

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

4

ПОЙНТИНГА — РОБЕРТСОНА
СТРИМЕРЫ

Главный редактор
А. М. ПРОХОРОВ

Редакционная коллегия

Д. М. АЛЕКСЕЕВ,
А. М. БАЛДИН,
А. М. БОНЧ-БРУЕВИЧ,
А. С. БОРОВИК-РОМАНОВ,
Б. К. ВАЙНШТЕЙН,
С. В. ВОНСОВСКИЙ,
А. В. ГАПОНОВ-ТРЕХОВ,
С. С. ГЕРШТЕЙН,
И. И. ГУРЕВИЧ,
А. А. ГУСЕВ
(зам. гл. редактора),
М. А. ЕЛЪЯШЕВИЧ,
М. Е. ЖАБОТИНСКИЙ,
Д. Н. ЗУВАРЕВ,
Б. Б. КАДОМЦЕВ,
Л. П. ПИТАЕВСКИЙ,
Ю. Г. РУДОЙ
(зам. гл. редактора),
И. С. ШАПИРО,
Д. В. ШИРКОВ

Москва
Научное издательство
«Большая Российская энциклопедия»
1994



ПОЙНТИНГА — РОБЕРТСОНА ЭФФЕКТ — потеря орбитального угл. момента телом (обычно малой частицей) при движении по орбите вокруг другого тела, являющегося источником эл.-магн. излучения. Автор идеи — Дж. Пойнтинг [1]. Х. Робертсон дал строгую релятивистскую теорию эффекта [2], исправив ошибки в статье [1].

На неподвижную сферич. частицу радиуса a на расстоянии r от Солнца действует сила *давления света*, направленная по радиусу-вектору частицы:

$$F = \frac{\pi^2 R_{\odot}^2 Q^2}{c r^2} \int I(\lambda) Q(a, \lambda) d\lambda = F_0 \frac{r}{r_0},$$

где $Q(a, \lambda)$ — фактор эффективности для давления излучения, I_{\odot} — спектральная интенсивность излучения Солнца, R_{\odot} — радиуса Солнца, λ — длина волны. Если частица движется с радиальной скоростью r и трансверсальной скоростью $r\dot{\varphi}$ (φ — угол поворота в плоскости орбиты), то сила F из-за *абберации света* отклонится от радиуса-вектора и изменится по величине (в системе покоя частицы). С точностью до членов первого порядка по отношению скорости частицы к скорости света радиальная и трансверсальная составляющие силы лучевого давления соответственно равны

$$F_r = F_0(1 - 2r/c), \quad F_{\varphi} = -F_0 \dot{\varphi} c$$

и ур-ния орбитального движения частицы приобретают вид

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -(GM_{\odot} - \alpha c)r^{-2} - 2\alpha \dot{r} r^{-3}, \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt}(r^2 \dot{\varphi}) = -\alpha \dot{\varphi}, \quad (2)$$

где G и M_{\odot} — гравитационная постоянная и масса Солнца. Для случая $Q=1$ (абсолютно чёрная переналающая астроноич. частица) Робертсон получил значение $\alpha = 3,55 \cdot 10^{-8} (ap)^{-1}$ а.е. в год, где p — плотность вещества частицы (a — в см, p — в г. см⁻³). Т.о., излучение влияет на орбитальное движение тел: изменяется эфф. масса центра притяжения, к-рый при $a > GM_{\odot}/c$ может превратиться в центр отталкивания; возникает направленная против радиальной скорости сила трения $2\alpha \dot{r} r^{-3}$, стремящаяся превратить орбиту в круговую; и, как это следует из ур-ния (2), происходит потеря момента импульса, превращающая орбиту в скручивающуюся спираль (П. — Р. э. в узком смысле).

Частица, находящаяся на круговой орбите радиуса r_0 , упадет на Солнце через время $t = r_0^2/4\alpha = = 7 \cdot 10^8 ap r_0^2$ лет.

П. — Р. э. учитывается [в широком смысле, т.е. ур-ния (1), (2)] в теории эволюции метеороич. вещества в Солнечной системе, а также в космогонии планетных систем [4]. В. В. Радзиевский [3] показал, что П. — Р. э. проявляется также при движении пылевых частиц вокруг планет.

Лит.: 1) Poynting J. H., Radiation in the Solar system: its effect on temperature and its pressure on small bodies, «Phil. Trans. Royal Soc. of London», 1903, v. A202, p. 525; 2) Robertson H. P., Dynamical effects of radiation in the Solar system, «Mon. Not. Roy. Astron. Soc.», 1937, v. 97, p. 423; 3) Радзиевский В. В., Планетоцентрический эффект лучевого торможения, «ДАН СССР», 1950, т. 74, № 2, с. 197; 4) Альветт Х., Аррениус Г., Эволюция Солнечной системы, пер. с англ., М., 1979.

ПОККЕЛЬСА ЭФФЕКТ — линейный электрооптич. эффект, состоящий в изменении показателей преломления света в кристаллах под действием внеш. электрич. поля пропорционально напряжённости электрич. поля E . Следствием этого эффекта в кристаллах является *двойное лучепреломление* или изменение величины уже имеющегося двулучепреломления.

П. э. был впервые изучен Ф. Поккельсом (F. Pokkels) в 1893. Квадратичный и др. эффекты более высокого порядка много меньше П. э., однако в центросимметричных средах П. э. обращается в нуль и осн. роль играет квадратичный *Керра эффект*.

Математически П. э. описывается изменением оптич. индикатрисы кристалла (см. *Кристаллооптика*) — эллипсоида показателей преломления, к-рый в главной кристаллофиз. системе координат имеет вид

$$a_{10}x^2 + a_{20}y^2 + a_{30}z^2 = 1. \quad (1)$$

Здесь x, y и z — гл. оси кристалла, т.е. направления, вдоль к-рых векторы электрич. поля E и электрич. индукции D параллельны друг другу, $a_{10} = 1/n_x^2$, $a_{20} = 1/n_y^2$, $a_{30} = 1/n_z^2$, n_x, n_y и n_z — показатели преломления для света, поляризованного вдоль осей x, y и z соответственно. Величины показателей преломления определяются распределением зарядов внутри кристалла. Наложение внеш. электрич. поля, малого по сравнению с внутр. полем кристалла, приводит к перераспределению связанных зарядов и небольшой деформации ионной решётки, что сопровождается изменением показателей преломления и, следовательно, коэф. эллипсоида a_{10}, a_{20}, a_{30} . Гл. оси нового эллипсоида в общем случае не будут совпадать с исходными гл. осями, ур-ние эллипсоида примет вид:

$$a_1 x^2 + a_2 y^2 + a_3 z^2 + 2a_4 xy + 2a_5 xz + 2a_6 yz = 1. \quad (2)$$

В П. э., как эффекте линейном, рассматривается только линейная по полю E часть изменения коэф. эллипсоида, поэтому

$$a_k - a_{k0} = r_{k1} F_x + r_{k2} E_y + r_{k3} E_z, \quad (3)$$

где $k = 1, 2, \dots, 6$; $a_{40} = a_{50} = a_{60} = 0$. Коэф. r_{ki} наз. постоянными Поக்கельса и определяют величину П. э. в разл. кристаллах.

П. э. существует в средах, лишенных центральной симметрии, называемых *пьезоэлектриками*. Симметрия кристаллов накладывает определённые ограничения на постоянные Поக்கельса, часть из них обращается в нуль, нек-рые могут оказаться равными между собой. Материал считается обладающим значит. электрооптич. эффектом, если его коэф. r_{ki} порядка 10^{-9} ÷ 10^{-10} см/В. Поэтому при обычных внеш. полях 10^4 В/см линейное изменение показателя преломления составляет $\sim 10^{-5}$. Это означает, что существенные изменения оптич. длин под действием П. э. могут быть получены только в тех случаях, когда длина кристалла в направлении распространения света \sim в 10^5 раз превышает длину волны света.

П. э. широко применяется при создании разл. устройств управления оптич. излучением, таких, как *модуляторы света*, дефлекторы, переключатели оптич. каналов и т. п. Обычно в этих устройствах используются кристаллы LiNbO_3 ($r_{33} = 30,8 \cdot 10^{-10}$ см/В), LiTaO_3 ($r_{33} = 33 \cdot 10^{-10}$ см/В), KH_2PO_4 ($r_{33} = 11 \cdot 10^{-10}$ см/В), KD_2PO_4 ($r_{33} = 26,8 \cdot 10^{-10}$ см/В) и др.

Значит. увеличение постоянных Поக்கельса происходит в сегнетоэлектрич. кристаллах при приближении к точке Кюри. Из зависимостей r_{33} от тем-ры для кристаллов KH_2PO_4 и KD_2PO_4 (рис. 1) видно, что в точке Кюри постоянные Поக்கельса увеличиваются в ~ 4500 раз по сравнению с комнатной тем-рой, что позволяет снизить управляющие напряжения. Однако трудности охлаждения кристаллов и поддержания с высокой точностью их тем-ры ограничивают применение устройств, работающих при тем-ре, близкой к тем-ре Кюри. Сегнетоэлектрики BaTiO_3 , $\text{KTa}_x\text{Nb}_{1-x}\text{O}_3$, $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{Nb}_2\text{O}_6$, имеющие точки Кюри вблизи комнатной тем-ры и большие коэф. $r_{ki} \sim 10^{-8}$ см/В, перспективны, однако, для создания устройств управления светом по своим оптич. качествам.

На практике П. э. часто маскируется вторичным электрооптич. эффектом, обусловленным деформациями пьезокристалла при наложении электрич. поля за счёт обратного *пьезооптического эффекта*. Эти деформации из-за наличия *фотоупругости* приводят к изменению показателя преломления, к-рое складывается с первичным П. э. При наличии деформаций изменение коэф. эллипсоида (3) должно быть записано в виде

$$a_k - a_{k0} = \sum_{i=1}^3 r_{ki} E_i + \sum_{j=1}^6 p_{kj} u_j, \quad (4)$$

где p_{kj} — коэф. фотоупругости, u_j — компоненты деформации, E_i — проекции электрич. поля на оси координат. Если к кристаллу не приложены внеш. напряжения, то деформации обусловлены только электрич. полем

$$u_j = \sum_{i=1}^3 d_{ji} E_i, \quad (5)$$

где d_{ji} — пьезоэлектрич. коэф. Подставив (5) в (4), имеем

$$a_k - a_{k0} = \sum_{i=1}^3 \left(r_{ki} + \sum_{j=1}^6 p_{kj} d_{ji} \right) E_i. \quad (6)$$

Выражение в скобках наз. *назочночастотной постоянной* Поக்கельса, т. к. именно эта величина измеряется при НЧ изменении электрич. поля. На очень высоких частотах деформации кристалла малы и имеет место только первичный П. э.

Особенно резко увеличиваются деформации на частотах, соответствующих собств. колебаниям кристалла.

Когда частота внеш. электрич. поля совпадает с одной из собств. частот деформации увеличиваются в Q раз, где Q — *добротность* соответствующего колебания. При таком резонансе электрооптич. коэф. может во много раз превышать 10^9 раз, что позволяет во столько же раз снизить управляющее напряжение. Однако это явление

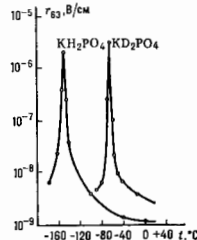


Рис. 1. Температурная зависимость постоянных Поக்கельса для кристаллов KH_2PO_4 (KDP) и KD_2PO_4 (DKDP)

наблюдается в узкой полосе частот и сильно зависит от тем-ры. Для улучшения частотной характеристики широкополосной модуляции света с помощью П. э. приходится специально демпфировать собств. колебания электрооптич. кристалла, однако и в этом случае переход от низких частот к высоким сопровождается изменением постоянной Поக்கельса за счёт пьезоэффекта. На рис. 2 приведены зависимости $r_{31} = (1/2)(n_{33}^2 r_{13} - n^2 r_{33})$ и $r_{32} = -3/2 r_{33}$ для кристалла LiNbO_3 с размерами $41 \times 3,3 \times 3,3$ мм³ от частоты, измеренные экспериментально. На низких частотах r_{31} и r_{32} определяются суммой первичного и вторичного П. э. При этом для r_{32} оба эффекта имеют одинаковый знак, а для r_{31} вторичный эффект имеет знак, противоположный первичному. Поэтому на высоких частотах r_{31} больше своего

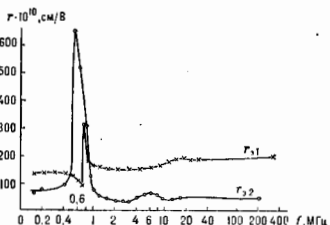


Рис. 2. Экспериментальная частотная зависимость постоянных Поக்கельса r_{31} и r_{32} для кристалла LiNbO_3 .

квасизначит. значения, а r_{32} — меньше. На частотах около 0,6 МГц имеет место собств. резонанс кристалла. ВЧ-значение постоянных Поக்கельса обычно не меняется вплоть до частот 10^{12} Гц, соответствующих частоте резонанса кристаллич. решетки.

Лит.: Мустель Е. Р., Парыгин В. Н., Методы модуляции и смандрования света, М., 1970; Солян А. С., Васильевская А. С., Электрооптические кристаллы, М., 1971.

ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМИОНОВ — сходные по свойствам группы (семейства) частиц — *кварков* и *лептонов*: (ν_e, e^-, u, d) , (ν_μ, μ^-, c, s) , (ν_τ, τ, t, b) .

Соответствующие частицы из каждого поколения имеют один и те же квантовые числа относительно группы симметрии *электрослабого взаимодействия* и отличаются только массами: каждое следующее поколение тяжелее предыдущего. Указанные три поколения содержат все известные в настоящее время кварки и лептоны.

Приведём состав первого П. ф., в к-ром частицы разбиты на дублеты и синглеты по группе $SU(2)$ электро-слабого взаимодействия:

$$\left(\begin{matrix} \nu_e \\ e^- \end{matrix} \right)_L, \left(\begin{matrix} u \\ d \end{matrix} \right)_L, u_R, d_R,$$

где e_L, e_R, \dots — соответственно левое (L) и правое (R) электроны и т. д. киральные поля (см. *Киральная симметрия*). Т. к. кварки образуют триплеты по группе цвета сильного взаимодействия $SU(3)_c$, то в каждом П. ф. насчитывается 15 двухкомпонентных вейлевских спиноров (см. *Вейль уравнение*).

В связи с существованием П. ф. теория должна ответить на два вопроса: почему фермионы объединяются в поколения и почему поколения повторяются? Модели *великого объединения* дают удовлетворит. ответ на первый вопрос. В простейшей $SU(5)$ -модели 15 фермионов разбиваются на представления 5 и 10 (см. *Представление группы*). В схеме, основанной на группе $SO(10)$, фундам. фермионы преобразуются по спинорному представлению, имеющему размерность 16, и предсказываются существование правого нейтрино (что не противоречит эксперименту). Т. о., каждое поколение в такой модели содержит 16 двухкомпонентных частиц. В теориях, основанных на группах более высокого ранга, предсказываются существование большего числа частиц в поколениях (напр., в случае группы E_6 — 27 частиц). Второй вопрос пока остаётся открытым и считается одним из основных в физике элементарных частиц. Вопрос этот возник еще в эпоху открытия *мюона* (μ^-) и формулировался так: зачем нужен μ^- и почему его масса сильно отличается от электронной, хотя все его известные взаимодействия такие же, как у электрона? Наиб. простым является предположение, что кварки и лептоны — составные объекты и все последующие поколения являются возбужденными состояниями первого. Частицы, из к-рых «построены» лептоны и кварки, получили назв. *преоны* (в см. *Составные модели*). Попытка динамики реализации такой возможности наталкивается на противоречие между сравнительно небольшими расстояниями между уровнями в спектре связанных состояний (для кварк. лептонов $m_e \approx 0,5$ МэВ, $m_q \approx 105$ МэВ, $m_s \approx 1,7$ ГэВ) и отсутствием *факторов* у лептонов и кварков вплоть до макс. экспериментально достижимых энергий (т. е. до 10^9 — 10^6 ГэВ). Экономной и последоват. преонной схемы пока нет. Другой, более глубокий подход связан с теориями типа Калуцы — Клейна (см. *Калуцы — Клейна теория*). При этом исходной является единая квантовая теория поля, обладающая высокой симметрией в многомерном пространстве-времени, на к-рой в результате компактификации образуется наш 4-мерный мир. Компактификация — это динамич. механизм, в результате к-рого по нек-рым измерениям в исходном пространстве размерности D спонтанно образуется компактное многообразие размерности $D - 4$, а оставшиеся 4 измерения соответствуют реальному пространству-времени. Степени свободы, отвечающие компактифицированным ($D - 4$) измерениям, отражаются во *внутренних симметриях* реального мира. Размер R компактного многообразия очень мал ($R \sim h/m_1 c \sim 10^{-33}$ см, где $m_1 \approx 10^{19}$ ГэВ/ c^2 — т. п. планковская масса, характеризующая обратную константу гравитацион. взаимодействия). Большинство частиц в таких схемах оказываются тяжёлыми, с массами порядка планковской. Кол-во безмассовых в этом масштабе частиц, а следовательно и число поколений, определяется геометрией компактного многообразия. В популярных совр. моделях, порождаемых теорией суперсимметричных струн (*суперструны*) в 10-мерном пространстве-времени, предсказываются существование 4 поколений, каждое из к-рых состоит из 27 частиц.

Лит.: Окунов Л. В. Лептоны и кварки, 2 изд., М., 1990; Wilczek F. E., Search for a realistic Kaluza — Klein theory, *Nucl. Phys.*, 1981, v. B 186, p. 412. М. И. Виссцюзки.

ПОЛЕ оптической системы (ранее наз. *поле зрения*) — часть пространства (или плоскости), изображаемая оптич. системой. П. определяется контурами оптич. деталей (такими, как оправы линз, призм), диафрагмами и т. п., к-рые ограничивают световые лучи. Величина П. определяется тем из контуров S_1, S_2 (рис.), к-рым виден центр A входного зрачка (см. *Диафрагма* в оптике) под наименьшим углом. Величина П. измеряется либо углом 2α , под к-рым виден контур S_1, S_2 и соответствующая часть предмета O_1, O_2 из центра A входного зрачка (у годовое П.), либо линейными размерами этой части O_1, O_2 (линейное П.). Системы, предназначенные для наблюдения за удалёнными объектами (телескопы, зрительные трубы), обычно характеризуются угловым П., а системы, в к-рых расстояния до объекта невелики (напр., микроскопы), — линейным П.

В общем случае плоскости объекта O_1, O_2 и контуры S_1, S_2 не совпадают и имеет место *виньетирование* (с шириной кольца BB_1 , рис.). Если же плоскость S_1, S_2 совмещена с плоскостью объекта, граница П. резка. Этого стараются добиться во мн. телескопах, зрительных трубах и др., помещая полевую диафрагму в фокальную плоскость объектива.

Угловое поле 2α в пространстве предметов изменяется для разл. типов оптич. систем в широких пределах; так, в биноклях оно составляет 5—10°, а в самых больших телескопах не превышает веск. угловых мин. В широкоугольных фотообъективах он достигает 120—140° и даже 180°. П. микроскопа определяется отношением П. окуляра $2l$ к линейному увеличению объектива β : $2l/\beta$.

Лит.: Тудоровский А. А., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1, М.—Л., 1948; Слюсарев Г. Г., Методы расчёта оптических систем, 2 изд., Л., 1968.

ПОЛЕВАЯ ЭМИССИЯ — то же, что *автомолетронная эмиссия*.

ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР — транзистор, в к-ром управление протекающим через него током осуществляется электрич. полем, перпендикулярным направлению тока. Принцип работы П. т., сформулированный в 1920-х гг., поясняется на рис. 1. Тонкая пластинка полупроводника (канал) снабжена двумя омич. электродами (п с т о к о м в с т о к о м). Между истоком и стоком расположено третий электрод — затвор. Напряженье, приложенное между затвором и любым из двух

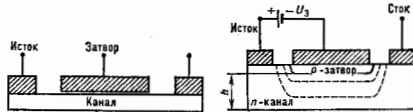


Рис. 1.

Рис. 2.

др. электродов (истоком или стоком), приводит к появлению в подзатворной области канала электрич. поля. Влияние этого поля приводит к изменению кол-ва носителей заряда в канале вблизи затвора и, как следствие, изменяет сопротивление канала.

Изготавливаются П. т. гл. обр. из Si и GaAs; исследуются также П. т. на основе InP, тройных твёрдых растворов AlSbV, а также *гетероструктур* GaAlAs/GaAs и InGaAs/InP и др.

Если канал П. т. — полупроводник n -типа, то ток в нём переносится электронами, входящими в канал через исток, и к-рому в этом случае прикладывается отрицат. потенциал, и выходящими из канала через сток,

Если канал П. т. — полупроводник p -типа, то к истоку прикладывается положит. потенциал, а к стоку — отрицательный. При любом типе проводимости канала ток всегда переносится носителями заряда только одного знака: либо электронами, либо дырками, поэтому П. т. наз. иногда униполярными транзисторами.

Различают 2 ос. типа П. т. К первому типу относят П. т., в к-рых затвором служит p - n -переход (П. т. с управляющим p - n -переходом) или барьер металл — полупроводник (*Шоттки барьер*). Ко второму типу относят П. т., в к-рых металлич. электрод затвора отделен от канала тонким слоем диэлектрика, — П. т. с изолированными затвором.

Идея, лежащая в основе работы П. т. с затвором в виде p - n -перехода, высказана в нач. 50-х гг. У. Шокли (W. Shockley, США). Она поясняется на рис. 2. Под металл. электродом затвора П. т. сформирован p -слой, так что между затвором и любым из двух др. электродов П. т. существует p - n -переход. Толщина канала d , по к-рому ток может протекать между истоком и стоком, зависит от напряжения, приложенного к затвору. Между истоком и затвором прикладывается напряжение U_a , смещающее p - n -переход в затворном направлении (в П. т. с каналом n -типа это условие соответствует «мигусу» на затворе). Тогда под затвором возникает обедненный слой (см. p - n -переход), имеющий очень высокое сопротивление. Чем больше напряжение U_a , тем больше толщина обедненного слоя. В пределах обедненного слоя ток практически течь не может. Поэтому увеличение U_a соответствует сужению канала, по к-рому протекает ток между истоком и стоком. Меняя напряжение на затворе, можно управлять током в канале. Чем больше U_a , тем толще обедненный слой и тоньше канал d , следовательно, тем больше его сопротивление и тем меньше ток в канале. При достаточной большой величине U_a обедненный слой под затвором может полностью перекрыть канал, и ток в канале обратится в нуль. Соответствующее напряжение $U_a = U_0$ наз. на г р я ж е в и е м о т с е ч к и.

Ширина области объемного заряда обратосмещенного p - n -перехода

$$W = \left[\frac{2\epsilon_0\epsilon(U_a + U_0)}{eNd} \right]^{1/2},$$

где e — заряд электрона, N_d — концентрация доноров в материале канала, ϵ — диэлектрик. проницаемость материала, $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — диэлектрик. постоянная, U_0 — контактная разность потенциалов в p - n -переходе. Очевидно, толщина канала $d = h - W$, где h — геом. толщина канала (рис. 2). Напряжение отсечки U_0 находится из условия $W = h$:

$$U_0 = \frac{eNd^3}{2\epsilon_0\epsilon} - U_N \approx \frac{eNd^3}{2\epsilon_0\epsilon},$$

Принцип работы П. т. с затвором в виде барьера Шоттки (ПТШ) аналогичен. Разница лишь в том, что обедненный слой в канале под затвором создается приложенным затворным напряжением к контакту металл — полупроводник.

ПТШ и П. т. с управляющим p - n -переходом, как правило, являются П. т. с нормально открытым каналом. Так принято наз. П. т., в к-рых при отсутствии напряжения на затворе ($U_a = 0$) канал открыт и между истоком и стоком возможно протекание тока. В цифровых устройствах для снижения потребляемой мощности применяют также нормально закрытые П. т. В этих приборах толщина канала d настолько мала, что канал под действием контактной разности потенциалов U_N при нулевом напряжении на затворе полностью обеднен носителями заряда, т. е. канал практически закрыт. Рабочей областью входных сигналов таких П. т. являются отрицательные значения U_a от 0 до $U_0 \approx U_N$.

В П. т. с изолиров. затвором между каналом П. т. и металлич. электродом затвора размещается тонкий

слой диэлектрика (рис. 3, 4). Поэтому такие П. т. наз. МДП-транзисторами (металл — диэлектрик — полупроводник; см. *МДП-структура*). Часто в МДП-транзисторе слой диэлектрика служит окисел на поверхности полупроводника. В этом случае П. т. наз. МОП-

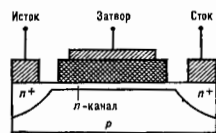


Рис. 2.

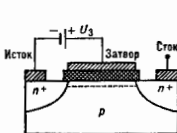


Рис. 4.

транзисторами (металл — окисел — полупроводник). Первые МДП-транзисторы появились в сер. 50-х гг.

МДП-транзисторы могут быть как с нормально открытым, так и с нормально закрытым каналами. МДП-транзистор с нормально открытым, встроенным каналом показан на рис. 3 на примере МДП-транзистора с каналом n -типа. Транзистор выполнен на подложке p -типа. Сверху подложки методами диффузии, *ионной имплантации* или *эпитаксии* формируются проводящий канал n -типа и две глубокие n^+ -области для создания омич. контактов в области истока и стока. Область затвора представляет собой конденсатор, в к-ром одной обкладкой служит металл, электрод затвора, а другой — канал П. т. Если между затвором и каналом приложить напряжение, то в зависимости от его знака канал будет обогащаться или обедняться подвижными носителями заряда. Соответственно, сопротивление канала будет уменьшаться или возрастать. В показанной на рис. 3 МДП-структуре с каналом n -типа напряжение, сплюс n -рого приложен к затвору, а «мигус» — к каналу (истоку или стоку), вызывает обогащение электронами приповерхностного слоя полупроводника под затвором. Обратная полярность напряжения на затворе вызывает обеднение канала электронами аналогично П. т. с управляющим p - n -переходом.

Для работы МДП-транзистора принципиально важно, чтобы поверхность раздела диэлектрик — полупроводник под затвором имела высокую плотность электронных *поверхностных состояний*. В противном случае изменение напряжения на затворе может приводить не к изменению концентрации носителей в канале, а лишь к перезарядке поверхностных состояний.

МДП-транзистор с индуциров. каналом показан на рис. 4. На сравнении рис. 3 и 4 видно, что этот транзистор отличается от МДП-транзистора со встроенным каналом отсутствием n -слоя под затвором. Если напряжение на затворе отсутствует ($U_a = 0$), то в МДП-транзисторе, показанном на рис. 4, отсутствует и канал (транзистор с нормально закрытым каналом), а сам транзистор представляет собой два последовательно включенных p - n -перехода. При любой полярности напряжения между истоком и стоком один из этих p - n -переходов оказывается включенным в обратном направлении и ток в цепи исток — сток практически равен нулю.

Если приложить к затвору напряжение U_a в такой полярности, как показано на рис. 4, то поле под затвором будет отгнать дырки и притягивать в подзатворную область электроны. При достаточно большом напряжении U_a , называемом напряжением отгираения, под затвором происходит инверсия типа проводимости: вблизи затвора образуется тонкий слой n -типа. Между истоком и стоком возникает проводящий канал. При дальнейшем увеличении U_a возрастает концентрация электронов в канале и сопротивление его уменьшается.

Осн. параметры П. т. Для П. т. характерно очень высокое входное сопротивление по пост. току $R_{вх}$.

Действительно, входной сигнал в П. т. подается на затвор, сопротивление r -го в П. т. с управляющим $p-n$ -переходом и ПТШ определяется сопротивлением обратного смещенного $p-n$ -перехода или сопротивлением барьера Шоттки, а в МДП-транзисторе — сопротивлением слоя диэлектрика. Величина $R_{вх}$ в П. т. обычно превосходит 10^8 Ом, в нек-рых конструкциях достигает 10^{14} Ом. Выходное сопротивление по перем. току практически определяется емкостью затвора $C_{зв}$ в сверхвысокочастотных П. т. величина $C_{зв} < 1$ пФ, в мощных низкочастотных П. т. величина $C_{зв} \approx 100$ пФ. Усилит. свойства П. т. характеризуются крутизной вольт-амперной характеристики S , определяемой как отношение изменения тока между истоком и стоком (тока стока) ΔI_c к изменению напряжения на затворе ΔU_z при пост. напряжении на стоке:

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_z} \Big|_{U_c = \text{const}}$$

При неизменной структуре прибора крутизна растёт прямо пропорционально ширине затвора B (рис. 5). Поэтому при сравнении усилит. свойств разл. типов П. т. используется понятие уд. крутизны S^* (отношение крутизны к ширине затвора B). Крутизна П. т.

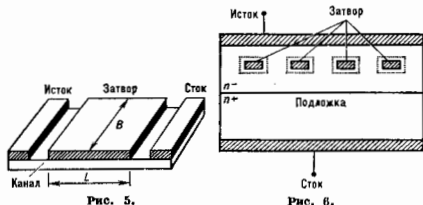


Рис. 5.

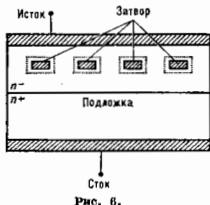


Рис. 6.

измеряется в сименсах, уд. крутизна — в сименсах/мм. В серийных П. т. $S^* \approx 0,05-0,2$ См/мм. В лаб. разработках достигнуты значения $S^* \approx 1,2$ См/мм при 300 К и ≈ 2 См/мм при 77 К.

П. т. относятся к маломощным приборам. Типичное значение коэф. шума (см. *Шумовая температура*) серийных П. т. $K_{ш} \approx 1-3$ дБ. Предельные ВЧ-свойства П. т. определяются временем пролёта носителей под затвором $t_{зп}$ вдоль канала. Макс. рабочая частота П. т. может быть оценена, как $f_{max} \sim 1/t_{зп} \sim v_{max}/L$, где L — длина затвора (рис. 5). Величина L в серийных П. т. составляет 0,5–10 мкм. В лаб. условиях широко исследуются приборы с $L \approx 0,1-0,25$ мкм. Величина v_{max} в кремниевых приборах не превосходит дрейфовой скорости насыщения $v_s \sim 1 \cdot 10^7$ см/с (см. *Лаинион-пропелл диод*). В П. т. на основе соединений $As^{III}V$ при $L \leq 0,5$ мкм важную роль играют т. н. баллистич. эфф. эффекты (движение носителей заряда без столкновений на длине канала), за счёт к-рых величина v_{max} возрастает до (4–6) $\cdot 10^7$ см/с. Предельная частота генерации П. т. превосходит 200 ГГц. Предельно малое время переключения П. т. ~ 5 пс.

Осн. разновидности П. т. По областям применения все П. т. можно условно разбить в 4 осн. группы: П. т. для цифровых устройств и интегральных схем (ЦУ и ИС), П. т. общего применения, сверхвысокочастотные П. т. и мощные П. т.

П. т., предназначенные для работы в ЦУ и ИС, должны обладать малыми габаритами, высокой скоростью переключения и мин. энергией переключения. Серийные П. т. для ЦУ и ИС в наст. время изготавливаются в осн. на Si и характеризуются следующими параметрами: длина затвора ~ 1 мкм, время переключения ~ 1 нс, энергия переключения ~ 1 пДж. Лучшие результаты получены с использованием П. т. на основе гетероструктур с селективным легированием (ГСЛ) [3, 4]. В ГСЛ-

транзисторах, называемых также транзисторами с высокой подвижностью электронов (ВПЭТ), используются свойства двумерного электронного газа, образующегося в нек-рых гетероструктурах на границе узкозонного и широкозонного слоёв гетероэпители. С использованием гетероэпители GaAlAs/GaAs получены ГСЛ-транзисторы с временем переключения 5 пс и энергией переключения $\sim 2,0 \cdot 10^{-14}$ Дж. Исследуются также ГСЛ-транзисторы с использованием др. гетероэпители на основе соединений $As^{III}V$.

Осн. требование к сверхвысокочастотным П. т. состоит в достижении макс. мощности или коэф. усиления на предельно высокой частоте. Продвижение в область высоких частот требует уменьшения длины затвора и макс. использования баллистич. эффектов для достижения высокой скорости носителей. Для изготовления сверхвысокочастотных П. т. в наст. время используются в осн. GaAs, в к-ром баллистич. превышение скорости над максимально возможным равновесным значением выражено значительно сильнее, чем в Si. Серийные СВЧ П. т. работают на частотах до ~ 40 ГГц. Лаб. разработки проводятся на частотах 90–110 ГГц. Предельная частота генерации (230 ГГц) получена в ГСЛ-транзисторах на основе GaAs/InGaAs, изготовленных с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии.

Мощные П. т. работают при напряжении в цепи канала $\sim 10^3$ В и коммутируемом токе ~ 10 А. Т. к. мощность на единицу рабочей площади структуры принципиально ограничена необходимостью отводить тепло, мощные П. т. имеют большую общую длину электродов. Часто используются встречно-штыревая система электродов [2]. Мощные П. т. изготавливаются на основе Si и GaAs. Характерные рабочие частоты мощных П. т. достигают величины $\sim 10^3$ МГц.

Новые разновидности П. т. Транзисторы с проиц. в осн. базой (ТПБ) предложены в 1979 и, по оценкам, способны, в принципе, повысить рабочую частоту П. т. до 10^{13} Гц (1 ТГц). Носители заряда в канале ТПБ движутся не вдоль поверхности полупроводниковой плёнки, а перпендикулярно ей. Длина канала, и следовательно время пролёта носителей, в ТПБ могут быть значительно уменьшены в сравнении с планарными П. т. При планарной конструкции мин. размер затвора L определяется возможностями рентг. или электронно-лучевой микрофотографии: $L \geq 0,1$ мкм (1000 Å). Предельно малая величина L в ТПБ определяется толщиной плёнки, к-рая может быть получена в совр. установке молекулярно-лучевой эпитаксии, и составляет неск. атомных слоёв.

Электроны в ТПБ (рис. 6) движутся от истока к стоку в направлении, перпендикулярном поверхности плёнки. Затвором служит металлч. сетка, «погружённая» в толщу полупроводниковой структуры ТПБ. По принципу действия ТПБ аналогичен ПТШ. Между металлч. сеткой и полупроводником возникает барьер Шоттки. Толщина обеднённой области вблизи проводника сетки определяется напряжением на затворе. Если толщина обеднённой области меньше расстояния между проводниками сетки, канал открыт и электроны свободно движутся к стоку. При достаточно большом напряжении обеднённая область перекрывается — канал закрыт. Осн. проблема создания ТПБ состоит в получении качеств. границ раздела металл-полупроводник. ТПБ имеет большое сходство с электронной лампой, в к-рой управляющим электродом является металлч. сетка.

Др. разновидностью П. т., в к-ром достигается уменьшение длины канала,

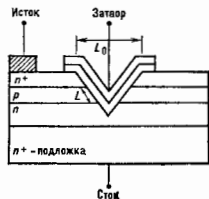


Рис. 7.

является П. т. В-канавкой (рис. 7), к-рый по принципу действия представляет собой МДП-транзистор с индиффер. каналом. Однако длина канала в такой структуре определяется не размером канавки в её верх. части L_0 (рис. 7), а толщиной p -слоя и углом между склонами канавки и слоями П. т. Длина затвора в такой конструкции может быть в неск. раз меньше, чем в планарном П. т. Изготовление П. т. с В-канавкой основано на анизотропии травления Si и GaAs при определ. ориентации поверхности полупроводниковой структуры.

Нек-рые др. типы быстродействующих транзисторов рассмотрены в [3, 4].

Лит.: Кроуфорд Р. Схемные применения МОП-транзисторов, пер. с англ., М., 1970; Зи и С., Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., кн. 1—2, М., 1984; Пожеев Ю. Ю. и Циц В., Физика сверхрешетчатых транзисторов, Вильнюс, 1985; Шур М., Современные приборы на основе арсенида галлия, пер. с англ., М., 1981.

М. Е. Делингштейн, Г. С. Сильин.

ПОЛУЧЕСТИ ТЕОРИЯ математическая — раздел механики сплошных сред, в к-ром изучают процессы медленного деформирования (течения) твёрдых тел под действием пост. напряжения (или нагрузки). В силу различия физ. механизмов, приводящих к возникновению временных эффектов, единой П. т. не существует. Наиб. развитие получили варианты П. т., описывающие поведение наиб. распространённых конструкц. материалов: металлов, пластмасс, композитов, грунтов, бетона. Осн. задача П. т. — формулировка таких матем. зависимостей между деформацией ползуемости (или её скоростью) и параметрами, характеризующими состояние материала (механизм, напряжения, темп-ра, повреждённость и др.), к-рые бы достаточно полно отражали осн. наблюдаемые в экспериментах свойства. К П. т. непосредственно примыкает теория т. и длит. прочности, описывающие разрушение материалов при выдержке в условиях постоянной или слабо меняющейся нагрузки.

Механич. характеристики ползуемости и длит. прочности конструкц. материалов обычно определяют в опытах на растяжение или сжатие цилиндрич. образцов (одноосное напряжённое состояние) либо путём испытаний трубчатых или плоских образцов при разл. комбинациях нагрузок (сложное напряжённое состояние). Длительность испытаний зависит как от уровня нагрузок, так и от задач использования данного материала в конкретных конструкциях. Она может колебаться от неск. минут до решения техн. задач обработки металлов, непрерывной разливки, ракетной техники до сотен тысяч часов (стационарные турбины, строит. конструкции).

Наиб. распространение получили два подхода к построению П. т. В первом в качестве осн. соотношения принимается ур-ние состояния в виде

$$\dot{p} = f(\sigma, T, p, q_i), \quad (i=1, \dots, n), \quad (1)$$

где p — деформация ползуемости, σ — напряжение, T — темп-ра, q_i — т. п. параметры состояния, для к-рых записывается система кинетич. ур-ний вида

$$dq_i = A_i d\sigma + B_i dp + C_i dT + D_i dt \quad (i=1, \dots, n), \quad (2)$$

где коэф. A_i, B_i, C_i и D_i сами могут быть ф-циями σ, T, p и q_i . Задавая конкретные виды ф-ций f, A_i, B_i, C_i и D_i , можно получить все известные, т. н. техн. П. т. Так, если принять, что параметр $q_i \equiv t$, получим теорию течения, а если ограничиться одним ур-нием (1), то теорию упрочения. Вводя параметр повреждённости ω (под к-рым понимается обобщённая мера микротрещин), получим соотношения вида $\dot{p} = f(\sigma, T, p, \omega)$ и $\dot{\omega} = \phi(\sigma, T, p, \omega)$, к-рые позволяют описать как процесс ползуемости, так и длит. разрушение (обычно для сплошного, неповреждённого материала принимается $\omega = 0$, а условие разрушения — в виде $\omega = 1$). Введение двух параметров повреждённости ω и Ω позволяет описать наиб. характерные эффекты длит. прочности. Соотношения (1) и (2) позволяют учесть все осн. участки кривых простой ползуемости (когда

испытания проводятся при пост. напряжении). Кроме того, в них могут быть учтены и такие эффекты, как скачкообразное изменение скорости ползуемости при мгновенных догрузках и разгрузках и последствие.

Во втором подходе принимается зависимость вида $p = \Phi(\sigma, T)$, где под Φ понимаются нек-рый функционал по времени t . В частном случае, когда он может быть записан в виде

$$p = \int_0^t K(t, \tau, T) f(\sigma, T) d\tau,$$

получаем обычную теорию наследственности о ст. т. Величина $K(t, \tau, T)$, т. е. ядро последствие, характеризует, насколько в момент времени t ощущается влияние (последствие) на деформацию напряжения, к-рое действовало в более ранний момент времени τ . Т. к. напряжение действует и в др. моменты времени, то суммарное последствие учитывается интегрированием. Если ядро K зависит только от разности $t - \tau$, то имеем дело с нестаряющимся материалом, а если f является линейной ф-цией σ , то получается линейная теория наследственности. Когда K является экспоненциальной ф-цией от $t - \tau$, получаем известные модели вязкоупругих сред. В более общем случае Φ может быть представлено в виде ряда кратных интегралов по времени. Тогда получаем соотношение общей величины теории вязкоупругости.

Переход к сложному напряжённому состоянию осуществляется обычно принятием одной из двух гипотез для деформаций ползуемости: в первом случае принимается, что тензор деформаций ползуемости p_{ij} пропорционален дивантору тензора напряжений $p_{ij} = \lambda \delta_{ij}$, во втором принимается гипотеза о пропорциональности тензора скоростей деформаций ползуемости \dot{p}_{ij} тому же дивантору \dot{S}_{ij} . Первая — деформ. вариант, вторая — теория течения для сложного напряжённого состояния. Параметр λ определяется как отношение соответствующих инвариантов тензоров деформаций ползуемости и напряжений, для определения к-рых принимаются системы (1) и (2), куда в качестве параметров могут войти проанализованные инварианты тензоров напряжений и деформаций.

П. т. используется для анализа напряжённо-деформированного состояния и времени работоспособности элементов конструкц., материал к-рых обладает свойствами ползуемости и длит. прочности. Соотношения (1), (2) дополняют систему ур-ний равновесия и совместности до полной. В условиях ползуемости при пост. внеш. воздействиях может со временем произойти потеря несущей способности отд. элементов конструкц. и конструкц. в целом. Это относится, в частности, к проблеме устойчивости элементов тина арок и облоков, где возможна потеря устойчивости при нагрузках, существенно меньших, чем вызывающие мгновенную потерю устойчивости при нагружении. Важное значение имеют расчёты длит. прочности, когда возможно наступление мгновенного разрушения при длит. эксплуатации в условиях стационарного режима нагружения. П. т. позволяет найти оптим. режимы ряда техн. процессов высокотемпературной обработки металлов, изготовления композитных материалов и описать временные процессы при деформации грунтов, ледяных и др. природных сред.

Лит.: Работин Ю. Н., Ползуемость элементов конструкц., М., 1966; его же, Элементы наследственной механики твёрдых тел, М., 1977; Закономерности ползуемости и длительной прочности, Справочник, под ред. С. А. Шестерикова, М., 1983; Малинин Н. Н., Ползуемость в обработке металлов, М., 1986.

ПОЛУЧЕСТЬ МАТЕРИАЛОВ — непрерывная пластич. деформация материалов под воздействием пост. механич. нагрузки или напряжений. Ползуемости подвержены все кристаллич. и вморфные твёрдые тела при всех видах механич. нагрузок. П. м. наблюдают как при темп-рах, близких к темп-ре жидкого гелия, так и при близких к темп-ре плавления. Однако с увеличе-

нием темп-ры T скорость П. м. растёт, что ограничивает долговечность конструкций, работающих при пост. нагрузках и повш. темп-рах. Малая скорость П. м. — гл. требование, предъявляемое к жаропрочным материалам. Сущест. техн. значение имеет получение металлич. материалов и керамики при повш. темп-рах и давлениях.

Зависимость величины деформации ϵ от времени t при пост. темп-ре T и напряжении σ описывают т. н. кривой ползучести (рис. 1). Процесс П. м. условно

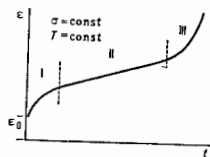


Рис. 1. Кривая ползучести.

разбивают на стадии: I — неустановившаяся П. м., когда скорость деформации $\dot{\epsilon}$ непрерывно понижается (происходит упрочнение); II — установившаяся П. м. $\dot{\epsilon}_{уст} = \text{const}$; III — стадия ускоренной П. м., к-рая заканчивается разрушением. Относит. протяжённость каждой стадии зависит от условий испытания или эксплуатации (предварит. обработки).

Стадия I предшествует т. н. мгновенная деформация ϵ_0 , к-рая возникает при приложении к испытываемому образцу (или в конструкции — к деталям) механич. нагрузки. При низких T величина сонамерима с деформацией, к-рая накапливается в течение всей последующей ползучести ($\epsilon \approx \epsilon_0$). При высоких T накапливаемая деформация $\epsilon \gg \epsilon_0$.

Неустановившаяся стадия ползучести. При повышенных T неустановившаяся стадия П. м. наблюдается только в тех случаях, когда σ вызывает появление ϵ_0 . Если ϵ_0 очень мала, то участок, соответствующий стадии I, тоже весьма мал.

Скорость деформации $\dot{\epsilon}$ в стадии I меняется со временем t по закону

$$\dot{\epsilon} = At^{-m}, \quad (1)$$

где A — постоянная, зависящая от σ и T ; $0 < m \leq 1$. При $m = 1$

$$\epsilon = a \ln t + \text{const}, \quad (2)$$

т. н. логарифмич. закон П. м. (a — постоянная, не зависящая от времени). Такая кинетика наблюдается при абс. темп-рах T от 0,05 до 0,3 $T_{пл}$ (темп-ры плавления материала) и $\epsilon < 0,3\%$. Согласно физ. модели, в недеформиров. материале имеется нек-рое кол-во источников дислокаций, к-рые активируются под влиянием приложенных σ и тепловых флуктуаций. Со временем их число иссякает. При повышении σ и T значение a и постоянная в ур-нии (2) увеличиваются, а величина m в (1) уменьшается. При $m = 2/3$

$$\epsilon = \beta t^{1/3} + \text{const}. \quad (3)$$

На многих металлах, материалах наблюдают параболич. ползучесть (или β -ползучесть). Величина β растёт с повышением T и σ .

Имеются эксперим. данные, полученные при повш. темп-рах, к-рые не описываются ни логарифмической, ни параболич. зависимостями. Поэтому предлежит ряд эмпирич. ур-ний, описывающих кинетику неустановившейся П. м., — степенные ряды, экспоненциальные ф-ции, комбинации раал. ф-ций.

Установившаяся ползучесть. Установившуюся П. м. рассматривают как динамич. равновесие процессов деформат. упрочнения и термич. возврата. Напряжения течения при этом не изменяются со временем. Это записывается следующим образом:

$$d\sigma = \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \epsilon} \right) d\epsilon + \left(\frac{\partial \sigma}{\partial t} \right) dt = 0, \quad (4)$$

где $\partial \sigma / \partial \epsilon = \chi$ — деформат. упрочнение, $\partial \sigma / \partial t = -\tau$ — термич. возврат, к-рый оценивают по уменьшению

напряжений текучести при отжиге. Из (4) следует

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \dot{\epsilon} = \tau / \chi.$$

Эксперименты, проведённые на металлах и сплавах, показывают, что $\dot{\epsilon}_{уст}$ и τ (с учётом влияния на возврат приложенных напряжений) совпадают. Непосредств. измерение $\dot{\epsilon}_{уст}$ и её оценки по эксперим. значениям χ и τ для одного и того же металла дают хорошее совпадение.

Экспериментально установлено два осн. вида зависимости $\dot{\epsilon}_{уст}$ от σ . В первом случае $\dot{\epsilon}_{уст} \geq 10^{-4}$ (E — модуль упругости) и $T < 0,5 T_{пл}$ справедливо соотношение

$$\dot{\epsilon}_{уст} = A_1 \exp(B\sigma), \quad (5)$$

где A_1 и B постоянные, не зависящие от σ . Соотношение (5) справедливо для мн. материалов (металлы и сплавы, керамика, полимеры, ионные кристаллы, полупроводники) в интервале σ , в к-ром $\dot{\epsilon}_{уст}$ изменялось на 10 порядков. Во втором случае $\dot{\epsilon}_{уст} = 10^{-4} - 10^{-6}$ и $T > 0,5 T_{пл}$ справедливо соотношение

$$\dot{\epsilon}_{уст} = A_2 \sigma^n, \quad (6)$$

где A_2 и n — постоянные, не зависящие от σ ; для металлов $n \approx 4-5$, а для металлич. твёрдых растворов $n \approx 3$.

С зависимостью $\dot{\epsilon}$ от σ связано понятие предела ползучести σ_c — напряжения, при к-ром скорость П. м. имеет нек-рую заданную величину. При малых σ , когда $\dot{\epsilon}$ и накапливаемая деформация ϵ весьма малы, отсутствует определённость относительно того, какая измеряется скорость, связанная со стадиями I и II или только со стадией II. Поэтому иногда под пределом ползучести понимают напряжение, к-рое вызывает заданную скорость П. м. через заранее установленный промежуток времени.

С темп-рой T скорость $\dot{\epsilon}_{уст}$ связана экспоненц. зависимостью

$$\dot{\epsilon}_{уст} \propto \exp(-C/T). \quad (7)$$

Величину C обычно представляют как $\Delta H/k$, где k — постоянная Больцмана, а ΔH — т. н. энергия активации ползучести. ΔH является частью свободной Гиббса энергии $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔS — изменение энтропии ползучести.

С учётом эмпирич. зависимостей $\dot{\epsilon}_{уст}$ от σ для относительно низких T и высоких σ

$$\dot{\epsilon}_{уст} = A_1 \exp\left(-\frac{\Delta H - \alpha\sigma}{kT}\right) \quad (8)$$

(α — активат. объём), а при $T > 0,5 T_{пл}$

$$\dot{\epsilon}_{уст} = A_2 \exp\left(-\frac{\Delta H}{kT}\right) \sigma^n. \quad (9)$$

Характер зависимости $\dot{\epsilon}_{уст}$ от T указывает на то, что П. м. является термически активируемым процессом, конкретный механизм к-рого зависит от свойств материала, темп-ры и напряжений. При низких T , когда диффузия подавлена, одним из таких процессов в кристаллич. материалах (прежде всего, в металлических и керамических) может быть преодоление сопротивления движению дислокаций со стороны периодич. потенц. поля кристаллич. решётки (т. н. внутр. напряжения $\sigma_{вн}$ Пайерлса — Набарро). Перемещение дислокаций в этом случае из одного положения в другое осуществляется не одновременно по всей её длине, а путём образования перегибов и их движения вдоль дислокации. При термич. активации перемещение дислокаций происходит при σ , меньших чем $\sigma_{вн}$. П. м. с таким механизмом наблюдают при $T < 0,2 T_{пл}$. Величина ΔH для металлов составляет 20–75 кДж/моль, т. е. ϵ замечается с темп-рой незначительно.

При T от 0,2 до 0,5 $T_{пл}$ $\dot{\epsilon}_{уст}$ определяется тем, что скольжение дислокаций тормозится др. дислокациями, к-рые провязывают плоскости скольжения. Пересече-

ние дислокаций также термически активируемый процесс, связанный с образованием ступек на расщеплённых дислокациях (степень расщепления зависит от энергии дефектов уаковки и величины σ , действующих на дислокациях). В этой же области темп-р прелятия скользямо дислокаций могут преодолеться путём поперечного скольжения. Переход расщеплённых дислокаций с одной плоскости на другую в результате поперечного скольжения также требует термич. активации процесса стяжки дефекта уаковки расщеплённых дислокаций. В изложенных случаях зависимость $\dot{\epsilon}_{уст}$ от σ и T описывается выражением (8), в к-ром актив. объём и предэкспонен. множитель зависят от конкретного атомного механизма возврата. При $T > 0,5 T_{пл}$ скорость П. м. зависит от диффузионных процессов возврата. Если последний осуществляется путём переползания дислокаций от мест, где они застопоены (поля напряжений др. дислокаций и их образований), границы зёрен и пр.), то $\dot{\epsilon}_{уст}$ описывается выражением

$$\dot{\epsilon}_{уст} \approx 100 \left[\frac{v_0 b^3}{A T^2 E M} \right]^{1/2} \exp \left(\frac{\Delta S}{k} \right) \sigma^{4,5} \exp \frac{\Delta H}{k T}. \quad (10)$$

Здесь v — частота колебаний атомов, b — вектор Бюргера дислокаций, M — число источников дислокаций, ΔH — энергия активации ползучести для металлов, к-рая совпадает с энергией активации самодиффузии.

Известны также дислокац. модели, в к-рых процессом, ограничивающим скорость ползучести, является диффузия точечных дефектов от порогов на винтовых дислокациях. Они приводят к зависимости $\dot{\epsilon}_{уст}$ от T и σ в виде (8).

При предплавленных темп-рах и напряжениях $\sigma/E < 10^{-3}$ наблюдают т. н. диффузионную П. м. $\dot{\epsilon}_{диф}$, к-рая описывается выражением вида (9) при $l = 1$. Такая П. м. осуществляется без участия дислокаций и связана с направленным диффузионным переносом атомов в поле градиента приложенных напряжений, что приводит к изменению формы материала. В частности, при одноосном напряжении поликристаллич. материала возникает градиент концентрации вакансий между продольными и поперечными границами зёрен. Поток вакансий отвечает равный по величине и обратный по направлению поток атомов (рис. 2). Эти потоки

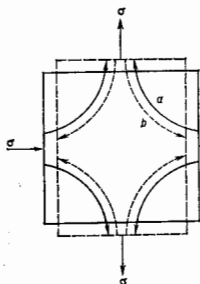


Рис. 2. Схематическое изображение потока атомов и поперечных границ (сплошные стрелки) и встречного потока вакансий в продольных границах (пустырные стрелки) в зёрне, к которому приложены напряжения.

приводят к удлинению зёрна в продольном направлении и сокращению в поперечном. Изменение формы зёрна сопровождается самоогласованным диффузионно-вязким течением по границам зёрен, что обеспечивает сохранение сплошности материала.

Диффузионная П. м. (т. н. Херринга — Набарро — Лифшица ползучесть) имеет пост. скорость и вызывает малую деформацию. Переползание неск. дислокаций в объёме зёрна приводит к более высокой скорости тече-

ния, чем чисто диффузионный механизм П. м. Скорость диффузионной П. м. зависит от темп-ры и напряжений

$$\dot{\epsilon}_{диф} = \frac{32b^3 D \sigma}{\pi^2 k^2 T} = \frac{32b^3 \sigma}{\pi^2 k^2 T} \exp \frac{Q_{диф}}{k T}. \quad (11)$$

Здесь b — межатоное расстояние, d — линейный размер элементов структуры (в частности, зёрен), D и $Q_{диф}$ — коэф. и энергия активации объёмной самодиффузии. Если процесс диффузии осуществляется гл. обр. по границам зёрен и зёрна мелкие, а темп-ры выше предплавленных, но более $0,5 T$, то диффузионная П. м., наз. ползучестью Кобла, определяется диффузией по границам зёрен:

$$\dot{\epsilon} = \frac{150 V \sigma}{d^2 k T} \omega D_{Гр}, \quad (12)$$

где V — атомный объём, ω — эфф. ширина границы, по к-рой идёт диффузия. Диффузионная П. м. — осн. механизм, к-рым осуществляется спекание дисперсных порошков. Этот вид П. м. является аккомод. механизмом снижения локальных концентраций напряжений, возникающих при ползучести.

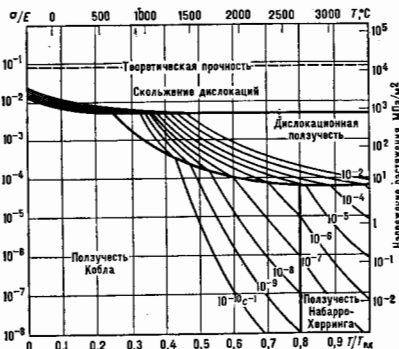


Рис. 3. Карта механизмов деформации при ползучести вольфрама (средняя величина зёрен 10 мкм).

Разнообразие механизмов деформации и зависимость их вклада в общую деформацию от величин T и σ для конкретных материалов наглядно иллюстрируются т. н. картами механизмов деформации (рис. 3), на к-рых проводят кривые, отвечающие пост. скорости ползучести, к-рые определяют экспериментальным или расчётным путём.

Ускоренная ползучесть и разрушение. П. м. на стадии III часто может занимать половину и более общего времени ползучести от нагружения и до разрушения. На ней накапливается значительная (иногда и большая) часть деформации. На стадии III, когда идёт ускоренный процесс П. м., кинетика деформации не описывается единой зависимостью. На нач. атаках, когда скорость $\dot{\epsilon}_{III}$ превышает на 10–20% $\dot{\epsilon}_{уст}$, деформация

$$\dot{\epsilon}'_{III} = \dot{\epsilon}_{уст} t + K t^{1/2}; \quad (13)$$

при больших скоростях $\dot{\epsilon}_{уст}$ величина деформации становится равной:

$$\dot{\epsilon}'_{III} = \dot{\epsilon}_{уст} + N \exp M t. \quad (14)$$

Здесь K , N и M — постоянные, к-рые зависят от материала и увеличиваются при повышении T и σ .

Ускоренную стадию наблюдают и в случае сжатия, когда сечение испытываемого объекта не уменьшается, а увеличивается. Установлено, что коэф. деформации, упрочнения λ на стадии III не изменяется, а остается таким же, как на стадии II. Однако резко изменяется скорость возврата — г. Для Fe $r_{\text{в}} = R_{\text{в}} \rho(r)$, где R и ρ — постоянные, зависящие от материала и режима испытаний. Имеется прямопропорц. связь между изменением скорости возврата и скорости ползучести на стадии III.

Если прервать проведение испытаний II, м. на первом этапе стадии III и провести отжиг, то свойства материала восстанавливаются. При переходе ко второму этапу стадии III II, м. кинетика к-рого описывается выражением (14), происходит необратимая поврежденность материала. Экспериментально для мн. материалов установлено постоянство произведения $\epsilon_{\text{уст}} \cdot t_p = \text{const}$ (t_p — время до разрушения).

Микроструктурные исследования разл. материалов в процессе II, м. выявили многообразные проявления дислокац. скопления (прямолинейные, волнистые, поперечные следы скольжения, складки у стыков зерен, полосы сброса). Установлено, что вблизи границ зерен действует большее число систем скольжения, чем в их объеме. Вдоль границ зерен возникают ступеньки, наблюдаются миграция границ, в объеме зерен образуются малоугловые субграницы, приводящие к фрагментации (полигонизации) исходных зерен, выделяется разорезнировка между образованными субзернами. Анализ наблюдаемых изменений микроструктуры показывает, что ползучесть кристаллич. материалов является гл. обр. результатом дислокац. деформации. Термич. возврат также связан с перераспределением и анигиляцией дефектов кристаллич. строения — линейных и точечных.

Стадия III II, м. оканчивается разрывом материала. Разрыв является лишь завершением процесса разрушения, к-рый протекает на всем или почти всем протяжении высокотемпературной II, м. Уже на стадии I обнаруживается образование всплывающих материалов, сопровождаемое уменьшением его плотности. На стадии II на границах зерен выявляются поры и трещины, слияние к-рых друг с другом приводит к окончат. разрушению материала. Зародыши трещин и пор могут быть в материале до начала процесса ползучести либо образоваться в результате деформации. Рост пор осуществляется путем диффузии вакансий к ним, взаимного слияния пор и при несогласованности проскальзывания зерен. Пути повышения сопротивления материалов также же, как для повышения прочности при комнатных темп-рах. Это — упрочнение растворимыми добавками и создание структуры, содержащей дисперсные частицы вторых фаз. Трудностью при создании материалов с высоким сопротивлением II, м. является не получение необходимой структуры и фазового состава материала, а их сохранение при высоких темп-рах длит. время.

Лит.: Физическое металловедение, 3 изд., т. 3, М., 1987, гл. 23; Розенберг В. М., Основы жаропрочности металлических материалов, М., 1978; Ретель В. Р., Служинер А. И., Томашевский Э. Е., Кинетическая природа прочности твердых тел, М., 1974; Зубарев П. В., Жаропрочность фаз внедрения, М., 1985; Чадек И. П., Ползучесть металлических материалов, пер. с чеш., М., 1987.

В. М. Розенберг.

ПОЛИГОНИЗАЦИЯ (от греч. *polygónos* — многоугольный) — перераспределение дислокаций, первоначально расположенных в плоскостях скольжения неакуратно, с образованием более или менее правильных степок (субграниц), разбивающих кристалл на фрагменты — субзерна. При II, м. происходит выигрыш энергии из-за упорядочения в расположении дислокаций. Наиб. устойчива и энергетически выгодна конфигурация краевых дислокаций одного знака при их расположении друг над другом в направлении, перпендикулярном плоскости скольжения (т. е. вертикальная стенка, или граница накована). Наиб. стабильному распо-

ложению винтовых дислокаций соответствует сетка пересекающихся дислокаций (граница кручения). Для образования таких конфигураций дислокаций необходимо не только их скопление, но и переползание, т. е. диффузия. Поэтому II, м. протекает (после небольшой пластич. деформации) лишь при достаточно высокой темп-ре. Но скорость переползания зависит не только от скорости притока точечных дефектов к дислокациям, но и от характера их взаимодействия (в частности, от числа порогов и ширины расщепления дислокаций). В связи с этим сложный процесс II, м. описывается одной энергией активации.

Процесс II, м. наглядно демонстрируется при отжиге слетка (чтобы не вызвать рекристаллизации) изогнутого монокристалла (рис. 1). Дислокация разного знака,

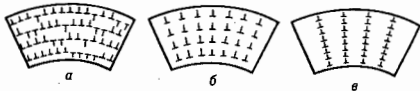


Рис. 1. Схема, иллюстрирующая распределение дислокаций в кристалле после изгиба и отжига: а — изгиб при низкой температуре; б, в — образование систем субграниц после нагрева.

встречаясь, аннигилируют, а оставшиеся встраиваются в стенки — субграницы. При этом кристалл разбивается на субзерна, разориентированные друг относительно друга на углы $\theta = b/\lambda$, где b — вектор Бюргерса, λ — расстояние между дислокациями в стенке (рис. 1, б). В процессе дальнейшего отжига происходит (разными путями, в т. ч. скоплением целых групп дислокаций) слияние близкорасположенных субграниц (рис. 1, в). Кол-во субзерен при этом уменьшается, а разориентировка между ними растёт.

II, м. кристалла может быть обнаружена рентгеновским или металлографич. методом. При II, м. первоначально вытянутое лауэвское пятно (астеризм) разбивается на ряд отдельных, более мелких и четких пятен. Металлографически II, м. обнаруживается по расположению микротравления (выходов дислокаций на поверхность кристалла) вдоль субграниц, к-рые при большой плотности дислокаций могут выглядеть как сплошные линии (рис. 2).



Рис. 2. Субструктура, возникшая в результате отжига изогнутого монокристалла кремнистого железа (3,4,5б). AA — субграница с большой плотностью дислокаций; BB — субграница с малой плотностью дислокаций. Увеличение 500.

Приложение незначит. нагрузки при отжиге существенно ускоряет процесс II, м. Закономерности влияния примесей на скорость II, м. неясны. Прочность полигонизов. кристаллов выше, чем отожженных.

Образование субграниц, аналогичных возникающим при II, м. в результате отжига после деформации, наблюдается также после весьма незначит. высокотемпературной пластич. деформации монокристаллов, ориентированных так, что возможно скольжение только по одной системе параллельных плоскостей. В этом случае образование степок из дислокаций связано с низким уров-

лем приложенных напряжений, недостаточных для прохождения дислокаций вал (или под) застрявшими дислокациями, лежками в близких и параллельных плоскостях скольжения. В отличие от П. при отжиге, такая П. ваз. механической. Лит.: В о и к о в И. П., Дефекты кристаллического строения металлов, 3 изд., М., 1983.

ПОЛИКРИСТАЛЛ — агрегат мелких монокристаллов разл. ориентации, наз. кристаллитами, блоками или кристаллами. Зёрнами. Свойства П. обусловлены как самими монокристаллич. зёрнами, их ср. размером (от $1-2 \cdot 10^{-9}$ м до деск. см), ориентацией, так и межзёрнными границами. Если зёрна малы и ориентированы хаотически, то в П. не проявляется анизотропия свойств, характерная для монокристаллов. Если есть преимуществ. ориентация зёрна, то П. является текстурированным и обладает анизотропией (см. Текстура).

Обычно в П. имеется большое кол-во дислокаций и точечных дефектов (вакансий, примесных и межзёрных границ атомов). Диффузия дефектов вдоль межзёрнных границ отличается от диффузии через кристаллич. зёрна. Межзёрные границы могут служить источниками и «стоками» вакансий, «ловушками» для примесей, местами закрепления дислокаций. Граница раздела 2 зёрна, разориентированных на малый угол, представляет собой «стенку» из параллельных дислокаций.

Межзёрные границы влияют на механич. свойства П. (см., напр., Пластичность кристаллов), а также на процессы переноса, т. к. на этих границах происходит рассеяние электронов проводимости, фононов. Это особенно существенно при низких темп-рах, когда длины свободного пробега квазичастиц велики.

Наличие межзёрных границ приводит к тому, что энергия П. выше, чем в монокристалле из тех же частиц, т. е. П. представляет собой метастабильное состояние твёрдого тела. Однако при затверждении вещества, если не принимать спец. мер по наблюдению однородности, то, как правило, образуется именно П., а не монокристалл (см. Кристаллизация). Поэтому большинство твёрдых тел (минералы, металлы, сплавы, керамики и др.) находятся в поликристаллич. состоянии. П. образуются также при спекании кристаллич. порошков. При длит. обжиге металл. П. происходит преимуществ. рост отд. зёрна за счёт других (рекристаллизация), приводящий к образованию крупнозёрнистых П. или монокристаллов.

П. можно использовать для определения кристаллич. структуры соответствующих монокристаллов: при облучении П. монохроматич. пучком проникающих частиц (рентгеновских квантов, нейтронов) наличие разориентированных монокристаллич. блоков фактически эквивалентно скачиванию по углу и позволяет восстановить обратную решётку монокристалла (см. Деба-Шеррера метод, Рентгенография материалов, Нейтронография структурная).

Лит. см. при ст. Кристаллы.

А. Я. Мейерович.

ПОЛИКРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА (мультикритическая точка) — особая точка на диаграмме состояния физ. системы, допускающей существование нескольких упорядоченных фаз. Разл. виды упорядочения в этих фазах (конфигурационное, ориентационное, магнитное, сверхпроводящее и др.; см. Дальний и ближний порядок) характеризуются многокомпонентным параметром порядка $\{\varphi_i\}$ ($i = 1, \dots, n$). Классификация П. т. зависит от числа термодинамич. параметров состояния, необходимых для описания системы на макроскопич. уровне (см. Равенствие термодинамическое). П. т. возникают и на диаграмме состояния в пространстве параметров гамильтониана, характеризующих систему на микроскопич. уровне (см., напр., Ренормализационная группа).

Термодинамич. параметры состояния можно разделять на внутренние $T, \{x_i\}$ (T — темп-ра, x_i — давление, P , поляризация \mathcal{P} , намагничённость M , хим.

потенциал μ и т. п.) и сопряжённые им внешние $\{X_i\}$ (X_i — объём V , электрич. поле E , магн. поле H , концентрация c). Условия термодинамич. устойчивости $dF = 0$, $d^2F > 0$ (минимум термодинамич. потенциала F) выделяют на диаграмме состояния области существования тех или иных упорядоченных фаз. Физ. системы условно могут быть разделены на два типа: если в системах 1-го типа отличные от 0 равновесные значения компонент параметра порядка φ_i зависят непосредственно от величин $T, \{X_i\}$, то в системах 2-го типа — ещё и косвенно благодаря взаимоддействию (связи) φ_i с другими («скрытыми») неупорядоченными степенями свободы той же системы. К системам 1-го типа относятся, напр., магнетки, в к-рых магн. упорядочение определяется взаимодействием только в спиновой подсистеме. Для систем 2-го типа существен учётом взаимодействия с решётчонной подсистемой (магнитострикция), подсистемой электронов проводимости или примесей (см. Косвенное обменное взаимодействие). Системы 2-го типа характеризуются, как правило, коэкзистующими взаимодействиями и допускают неск. видов упорядочения (см., напр., Магнитный фазовый переход, Магнитные сверхпроводники, Ориентационные фазовые переходы, Сегнетоэлектрики, Жидкие кристаллы, Спиновой плотности волны, Спиновое стекло, Магнитные полупроводники).

При изменении величин $T, \{X_i\}$ (или $\{x_i\}$) между упорядоченными фазами могут происходить фазовые переходы (ФП) — спонтанные (по T), индуцированные (по P, E или H) или концентрационные (по c). Равновесие фаз при ФП характеризуется равенством термодинамич. потенциалов; при этом их первые (для ФП 1-го рода) и вторые (для ФП 2-го рода) производные могут иметь разрывы или др. особенности. В простейшем случае спонтанный ФП 2-го рода происходит в изолиров. точке T_c (см. Кюри точка, Неелл точка, Сверхтекучесть, Сверхпроводимость). Если действие обобщённых полей $\{X_i\}$ не устраняет особенности термодинамич. потенциала и его производных, то на диаграмме состояний возникает линия (поверхность) ФП — фазовая граница $T_c(\{X_i\})$.

Классификация. Возможны два вида П. т.: 1) ФП вдоль фазовой границы сохраняет изоморфность (род ФП не меняется), что обычно характерно для систем 1-го типа. П. т. определяется пересечением двух или более фазовых границ; 2) изоморфность ФП вдоль фазовой границы нарушается. П. т. представляет собой особую точку на линии ФП, в к-рой это происходит. Такая ситуация реализуется в осн. в системах 2-го типа. Примером изоморфных линий ФП в случае равновесия двух фаз — упорядоченной (дальний порядок) и неупорядоченной (ближний порядок) — является линия ФП 2-го рода в одноосном ферромагнетике (рис. 1), а для ФП 1-го рода фазовая граница жидк-

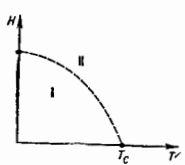


Рис. 1. Фазовая диаграмма одноосного ферромагнетика в магнитном поле H , перпендикулярном оси анизотропии, T_c — точка Кюри.

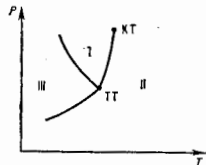


Рис. 2. Фазовая диаграмма системы газ (I) — жидкость (II) — твёрдое тело (III).

кость — тв. тело (рис. 2). Фазовая граница жидкость — газ обладает особенностью: она заканчивается критической точкой, аналогичной точке ФП 2-го рода. В критической точке нарушается изоморфность ФП, поэтому

она — простейший случай П. т. 2-го вида. Полная диаграмма состояния обнаруживает др. особенность: *тройную точку*. Это П. т. 1-го вида, в к-рой пересекаются три фазовые границы и находится в равновесии 3 фазы. В более общем случае *полиморфизма* возможны другие П. т., определяемые пересечением линий ФП между разл. кристаллич. модификациями.

Обозначения и определения некоторых поликритических точек (рис. 2 и 3)

Обозначение	Название и пример	Определение
КТ	Критическая точка. Рис. 2	Точка нарушения изоморфности ФП 1-го рода, эквивалентная ФП 2-го рода.
ТТ	Тройная точка. Рис. 2	Точка пересечения трёх линий ФП 1-го рода.
БКТ	Бикритическая точка. Рис. 3, а, б	Точка пересечения двух линий ФП 2-го рода и одной линии ФП 1-го рода.
ТКТ	Трикритическая точка. Рис. 3, а, б	Точка пересечения трёх линий ФП 2-го рода и одной линии ФП 1-го рода в линию ФП 2-го рода.
ЧКТ	Четырёхкритическая точка. Рис. 3, б	Точка пересечения четырёх линий ФП 2-го рода.
ТЛ	Точка Лифшица. Рис. 3, а	БКТ, для к-рой одна из упорядоченных фаз является несообразной.
ТО	Точка окончания. Рис. 3, а	Точка, в к-рой линия ФП 2-го рода пересекает линию ФП 1-го рода.

При расширении фазового пространства (напр., при добавлении термодинамич. параметра X') фазовая диаграмма может существенно модифицироваться. Фазовая диаграмма с ТКТ принимает вид симметричной фазовой поверхности («крылья бабочки», рис. 4, а); в ТКТ сходятся три линии ФП 2-го рода (это объясняет её назв.). В более общем случае фазовая диаграмма принимает вид, изображённый на рис. 4 (б), где возникают линии ТКТ, КТ, ТО. По-иному выглядят П. т. и при построении фазовой диаграммы в пространстве термодинамич. переменных $\{x_i\}$, T вместо $\{X_i\}$, T . Фазовая диаграмма с ТКТ принимает вид, изображённый на рис. 5, где область III соответствует смешанному (двухфазному) состоянию.

В общем случае в П. т. сходятся более трёх линий ФП, вдоль каждой из к-рых сосуществуют (находятся в термодинамич. равновесии) две фазы. В самой П. т. могут сосуществовать $r \geq 3$ фаз, что вполне согласуется с *Правилом правого фаз*. Согласно этому правилу, число термодинамич. степеней свободы f системы (число независимых переменных, к-рые можно изменять, не нарушая термодинамич. равновесия) должно быть неотрицательным, $f \geq 0$. В общем случае $f = n + 2 + k$, где n — число компонент системы, число 2 отражает кол-во термодинамич. параметров состояния, одинаковых для всех фаз (напр., темп-ра T и давление P), k соответствует наличию др. независимых обобщённых внеш. или внутр. параметров. Т. о., в общем случае $r \leq n + 2 + k$ (напр., для ТТ $n = 1$, $k = 0$, $r \leq 3$, а для ТКТ $k = 1$ и $r \leq 4$).

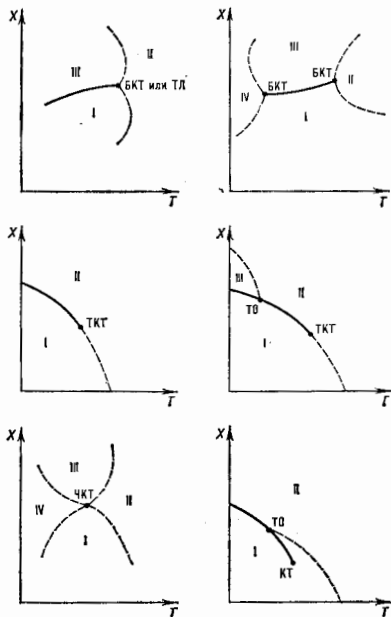


Рис. 3. Фазовые диаграммы ($X-T$) с поликритическими точками. Сплошная линия изобразает линию фазового перехода 1-го рода, штриховая — 2-го рода. Римскими цифрами (I, II, III, IV) обозначены различные фазы, одна из которых (обычно II) полностью неупорядоченна; X — внешний термодинамический параметр.

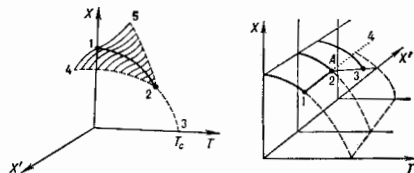
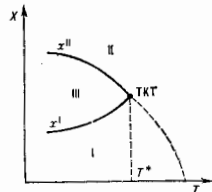


Рис. 4. Поликритические точки на трёхмерных фазовых диаграммах: а — 1—4—2—3 — поверхность фазового перехода 1-го рода, 1—2 — линия тройных точек, б — 1—2 — линия трикритических точек, 2—3 — линия критических точек, 2—4 — линия точек окончания, А — критическая точка 4-го порядка.

Рис. 5. Фазовая диаграмма ($x-T$) с трикритической точкой, x — внутренний термодинамический параметр. При $T < T^*$ фазовый переход происходит со скачком параметра $\Delta x = x^I - x^II$ (фазовый переход 1-го рода), при $T > T^*$ непрерывно (фазовый переход 2-го рода).



Примеры. Экспериментально изучено достаточно много физ. систем, обнаруживающих П. т. Наиб. известным примером системы с ТКТ является смесь изотопов ^3He — ^4He , для к-рой обобщённой силой X является разность хим. потенциалов этих изотопов, а внутр. параметром x — концентрация изотопа ^3He (фазы I и II — соотв. сверхтекучая и нормальная). Др. примерами может быть сегнетоэлектрик, упорядочение в KN_2PO_4 — внутр. элктрич. поле, x — поляризация, структурное упорядочение в соединениях Nb_2Sn , V_2Si (X — одноосное давление, x — компоненты тензора деформации).

В одноосных антиферромагнетиках X — внеш. магн. поле вдоль осей лёгкого намагничивания, x — проекция намагниченности на эту ось. При достаточно сильной аннотропии (FeCl_2 , DyPO_4) имеет место фазовая диаграмма с ТКТ (рис. 3, ϵ). Фаза I — антиферромагнитная, II — цесиферромагнитная (см. *Метамагнетик*, рис. 1). При слабой аннотропии (MnF_2 , $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) реализуется БКТ (рис. 3, α), фазы: I — антиферромагнитная, II — парамагнитная, III — синг-флоо (см. *Антиферромагнетизм*, рис. 4). В промежуточном случае возможна фазовая диаграмма, изображённая на рис. 3 (δ): с ростом аннотропии точка ТО движется в сторону более низких темп-р до тех пор, пока фаза синг-флоо не исчезнет; с уменьшением аннотропии точка ТО движется в сторону более высоких темп-р до слияния с ТКТ, в результате чего возникает БКТ. При наличии дополнительно аннотропии более высокого порядка (K_2MnF_4 , $\text{CoVr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) линия ФП 1-го рода на рис. 3 (α) расщепляется на две линии ФП 2-го рода, и БКТ переходит в ЧКТ (рис. 3, δ); аналогичное явление имеет место и при наложении на слабоаннотропный антиферромагнетик наклонного поля, образующего ненулевой угол с осью аннотропии. ТЛ наблюдается при ФП в состоянии волны спиновой плотности в чистом Cr , а также при переходах в магн. модулированные структуры редкоземельных металлов и их соединений (см. *Несоразмерная магнитная структура*).

Феноменологическое описание П. т. возможно в рамках *Ландау теории* фазовых переходов. В простейшем случае физ. система описывается однокомпонентным веществом (скалярным) параметром порядка q ; как правило, система обладает симметрией относительно замены $q \rightarrow -q$. Тогда уд. термодинамич. потенциала $F(q, \{X_i\})$, ТЛ вблизи точек ФП имеет вид разложения по чётным степеням q :

$$Fq = F_0 + a_2 q^2 / 2 + a_4 q^4 / 4 + a_6 q^6 / 12 + \dots - h q, \quad (1)$$

где $F_0(T, \{X_i\})$ — несингулярная часть термодинамич. потенциала, коэф. $a_{2n} = a_{2n}(T, \{X_i\})$ зависят от темп-ры и параметров $\{X_i\}$, h — внеш. поле, термодинамически сопряжённое q .

Обычная КТ соответствует учёту в (1) членов 2-го и 4-го порядков (модель ϕ^4) и определяется условиями $h = 0$, $a_2 = 0$, $a_4 > 0$. Выше КТ реализуется высокосимметричная фаза с $q = 0$, ниже — единственная низкосимметричная фаза с ненулевым равновесным значением параметра порядка q_0 , определяемым из условия $\partial F / \partial q = 0$ и равным $q_0^* = -a_2 / a_4$ (условия устойчивости этой фазы $\partial^2 F / \partial q^2 \geq 0$, т. е. $a_2 \leq 0$, $a_4 > 0$). Учёт члена 6-го порядка с $a_6 > 0$ (модель ϕ^6) приводит к появлению двух различных высокосимметричных фаз с равновесными значениями параметра порядка:

$$\left[q_0^{(1,2)} \right]^2 = -\frac{a_2}{a_4} \left[1 \pm \left(1 - \frac{2a_2 a_6}{a_4^2} \right)^{1/2} \right]. \quad (2)$$

Условия устойчивости для этих фаз: $a_2 \leq 0$, $a_4 > 0$ (для фазы $q^{(1)}$) и $a_2 < a_2^* / 2a_6$, $a_4 < 0$ (для фазы $q^{(2)}$). Область устойчивости высокосимметричной фазы ($q = 0$), как и в модели ϕ^4 , определяется условием $a_2 > 0$.

ФП из высокосимметричной фазы в высокосимметричную $q^{(1)}$ (как и для обычной КТ) происходит при $a_2 = 0$ и является ФП 2-го рода. ФП в др. фазу $q^{(2)}$ происходит при условии $a_2 = 3a_2^* / 8a_6$ и является ФП 1-го рода. Пересечение линий этих ФП определяет ТКТ, к-рая, т. о., описывается условиями $a_2 = a_4 = 0$, $a_6 > 0$ и является единственной на фазовой плоскости $\{X, T\}$. В модели ϕ^6 при $a_2 = a_4 = a_6 = 0$, $a_8 > 0$ можно получать П. т., в к-рой сходятся линии ТКТ, КТ и ТО (рис. 4, δ). Вообще, оставляя в разложении (1) члены до ϕ^6 включительно, можно получить П. т., называемую КТ порядка k , если положить $a_2 = a_4 = \dots = a_{2k-2} = 0$, $a_{2k} > 0$; тогда обычная КТ является КТ 2-го порядка, а ТКТ — КТ 3-го порядка. В такой П. т. сходятся линии КТ порядка $k-1$ (соответствующие условиям $a_{2(k-1)} < 0$) и линия ФП 1-го рода с условием $a_{2k-2} < 0$. Наличие внеш. поля h делает возможным ТКТ и в модели ϕ^4 ; при этом линия $h = 0$, $a_2 > 0$ — линия ФП 2-го рода, а линия $h = 0$, $a_2 < 0$ — линия ФП 1-го рода (независимо от знака a_4); пересечение этих линий в точку $h = 0$, $a_2 = 0$ определяет ТКТ.

При двух скалярных компонентах q_1 и q_2 разложение (1) содержит дополнит. смешанный член вида $h' q_1 q_2$, поэтому при больших h возникает БКТ, а при малых — ЧКТ. При одном вектором q_1 и одном скалярном q_2 параметрах порядка простейший смешанный член имеет вид $h' q_1 q_2$, что приводит к эфф. перенормировке веш. поля h и появлению ТКТ. Аналогично возможна перенормировка и др. слагаемых выражения (1) — напр., смена знака a_4 , приводящая к ТКТ в модели ϕ^4 за счёт исключения «скрытых» степеней свободы с помощью условия термодинамич. равновесия.

Описание ТЛ на основе разложения (1) требует учёта производных q по координатам (градиентов) [напр., в виде $\sigma_1(\nabla^2 q^2) + \sigma_2(q^2 \nabla^2 q)$, $\sigma_2 > 0$]. Такой случай имеет место при описании *волн зарядовой плотности, магнитной атомной структуры* типа спиновой волны и др. ФП 2-го рода из высокосимметричной фазы $q_0 = 0$ в однородную низкосимметричную фазу $q_0 = \text{const} \neq 0$ происходит при $a_2 = 0$, $\sigma_1 > 0$, а в неоднородную (несоразмерную) низкосимметричную фазу $q_0(r) \sim \exp(i k_0 r)$, здесь $i = \sqrt{-1}$, r — пространственная координата, волновой вектор $|k_0| = (-\sigma_2 / 2\sigma_1)^{1/2}$ при $a_2 = 0$, $\sigma_2 < 0$. Переход между двумя низкосимметричными фазами является ФП 1-го рода, определяется условиями $a_2 = 0$, $\sigma_1 = 0$. В случае двухкомпонентного параметра порядка (q_1, q_2) при учёте градиентных членов чётных степеней $\sigma_1(q_1^2 + q_2^2)$ становится возможным описание произвольных локальных, или модулированных магн. структур. Учёт линейных градиентных членов (и в вариантах в Лифшица) $\sigma_1(q_1 \nabla q_1 - q_1 \nabla q_2)$ приводит к солитонной картине каскадного перехода в модулиров. фазу (т. н. «чертова лестница»).

Критические показатели. Микроскопич. модели (напр. *Двухмерные решёточные модели*) применяются для более точного, чем в теории Ландау, количественного описания П. т. При этом используются *критические показатели* (индексы), приближённо вычисленные с помощью *эпсилон-разложения* в рамках метода ренормализов. группы. Наличие П. т. означает возникновение неустойчивости фиксиров. точки семейства фазовых траекторий гамiltoniana, что приводит к изменению характера ФП и описывающих его критич. показателей, а также верх. критич. размерности d_c , определяющей применимость теории Ландау. (Уже в рамках теории Ландау критич. показатель β , описывающий температурную зависимость параметра порядка $\beta = 1/4$ для ТКТ.) Изменение d_c (для КТ $d_c = 4$, для ТКТ $d_c = 3$) указывает на малую роль *флуктуаций* вблизи ТКТ в реальных физ. системах; для КТ порядка

θ значение $d_c = 20/(\theta - 1)$. Для описания поведения термодинамик. величин вблизи обычной КТ (КТ 2-го порядка) достаточно 2 пядков (напр., α и γ — критич. показатели теплоёмкости и восприимчивости), тогда как для КТ порядка θ необходимо θ пядков. Остальные $\theta - 2$ независимых критич. индекса (ψ_i , где $i = 1, 2, \dots, \theta - 2$), появляются у КТ высших порядков. наз. кроссоверными.

В рамках гипотез скейлинга (см. *Масштабная инвариантность*) термодинамик. потенциал вблизи П. т. описывается зависимостью

$$F(T, \{X_i\}) \sim |t|^{2-\alpha} \left\{ \frac{g_i}{|t|^{\psi_i}} \right\},$$

где $t = 1 - T/T_\theta$, T_θ — темп-ра КТ порядка θ , щеловой показатель $\Delta = \beta + \gamma$, g_i — выражается через величину $\{X_i\}$. Величина $g_i = g_i / |t|^{\psi_i}$, как правило, наз. «скейлинговым полем», его роль пренебрежимо мала ($g_i \ll 1$), когда $\psi_i < 0$ или при $\psi_i > 0$ вдали от П. т. Влияние «скейлинговых полей» существенно в переходной области вблизи темп-ры кроссовера T_K , определяемой условием $|1 - T_K/T_\theta| \approx g_i^{1/\psi_i}$, т. е. $g_i \approx 1$. При дальнейшем приближении темп-ры к T_θ ($g_i \gg 1$) происходит кроссовер, т. е. полное изменение критич. поведения термодинамик. величин.

Лит.: Pfeifer T., Toulouse G. Introduction to the renormalization group and to the critical phenomena, L., 1977; Анисимов М. А., Городецкая Е. Е., Запрудский В. М., Фазовые переходы с взаимодействующими параметрами порядка, «УФН», 1981, т. 133, с. 103; Альтгольц А. Multicritical points, в кн. Critical phenomena, ed. by F. J. W. Mahe, B., 1983; Иванов Ю. А., Сыроматников В. Н., Фазовые переходы и симметрия кристаллов, М., 1984. Ю. Г. Рудой.

ПОЛИМЕРЫ (от греч. polymerés — состоящий из многих частей) — вещества, состоящие из макромолекул, т. е. молекулярных полимерных цепей. В химии полимеры наз. также высокомолекулярными соединениями. Существуют как природные (см. *Полимеры биологические*), так и искусственные, синтетич. П.

Осн. характеристика полимерной цепи — число мономерных звеньев N — наз. степенью полимеризации; молекулярная масса и контурная длина цепи прямо пропорциональны N . Для типичных синтетич. П. N лежит в диапазоне $10^3 - 10^6$; наиб. степень полимеризации имеют биополимеры ДНК, для них N достигает величин $\sim 10^8$ и больше. Вследствие цепного строения молекул и большой их длины ($N \gg 1$) П. приобретает специфич. физ. свойства: а) объединение мономерных звеньев в полимерные цепи лишает их свободы независимого трансляц. движения, т. е. ведёт к реакому уменьшению соответствующей трансляц. энтропии; благодаря этому для П. характерны аномально высокие восприимчивости ко мн. воздействиям (напр., механическим); б) последовательность звеньев в каждой полимерной цепи фиксируется при её синтезе, взаимопересечение цепей при движении макромолекул невозможно (топологический запрет; рис. 1), поэтому для П. характерны долговременная

кроссочит. деталей хим. строения мономерных звеньев и качественно (а часто и количественно) универсальны для П. разл. типа; г) макромолекулярные цепи формируют аннотропные электронные спектры, благодаря этому наряду с обычными диэлектрич. П. существуют также полимерные органические проводники, полупроводники, сверхпроводники и ферромагнетики.

Виды макромолекул. Полимерная цепь — осн. элемент структуры всех макромолекул. Один из примеров макромолекул — однократная одородная линейная цепь. Наряду с линейными существуют разветвлённые макромолекулы, простейшие из к-рых имеют вид гребёнок (рис. 2, а) или звёзд (рис. 2, б). В усло-

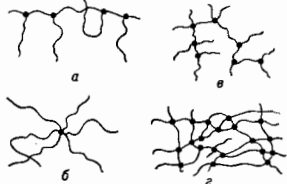


Рис. 2. Типы разветвлённых макромолекул: гребёнообразная (а), звездообразная (б), случайноразветвлённая (в) и сетчатая (г).

виях реального синтеза с участием мультифункциональных групп чаще всего возникают случайноразветвлённые макромолекулы (рис. 2, в); ретикулярная модель такого объекта получила в лит-ре назв. «вуэрушки» (lattice animals). Своего рода предельным случаем разветвлённой макромолекулы является макроскопич. полимерная сетка, или гель (рис. 2, г). Одна такая огромная молекула может быть размером во много сантиметров.

В простейших макромолекулярных цепях все звенья одинаковы — такие цепи наз. гомополимерными; к этому классу относится большинство распространённых синтетич. макромолекул. В гетерополимерных (по хим. терминологии — сополимерных) цепях звенья могут быть нескольких разных сортов. К гетерополимерам относятся полимеры биологические: молекулы ДНК (4 типа звеньев) и белков (20 типов). Другой важный класс гетерополимеров — блоксополимеры, их молекулы состоят из длинных гомополимерных участков (блоков) разных сортов.

Неразветвлённые макромолекулы могут быть кольцевыми. Т. к. участки цепей не могут пересекать (т. е. проходить сквозь) друг друга, достижимые состояния системы кольцевых макромолекул ограничены одним топологич. классом — тем, к-рый сформировался в момент синтеза. Принято говорить, что кольцевые макромолекулы «помнят» свою топологию — тип узла, образованного каждым кольцом, и типы зацеплений колец друг за друга (рис. 3). Система кольцевых макромолекул, сцепленных топологически, но не соединённых химически, наз. катенаем, а если их макроскопическое кол-во — олимпийским гелем.

Особый класс макромолекул составляют те, у к-рых звенья (все или нек-рые) могут нести электрич. заряды (за счёт диссоциации в жидкой среде). Если все заряды звеньев одного знака (и электрострательность обеспечивается взаимодействием с окружающей средой), то макромолекулу наз. полиэлектролитной. Макромолекулу гетерополимерную, включающую звенья с зарядами обоих знаков, наз. полиамфолитной.

Гибкость полимерных цепей. Тепловые флуктуации валентных углов и повороты звеньев макромолекулы вокруг единичных валентных σ -связей (см. *Молекула*) приводят к изгибанию хаотич. изгибанию полимерной цепи в пространстве. Количества характеристич. степеней гибкости полимерной цепи — т. н. п е р-

Рис. 1. К понятию топологического запрета в полимерных системах: прямой переход между состояниями (а) и (б) невозможен.

или даже практически неограниченная (линейная и топологическая) память об условиях синтеза и предыстории относит. движения звеньев; в) макромолекулярные цепи создают дальнействующие корреляции, благодаря этому специфические для П. физ. свойства формируются достаточно большими (по сравнению с атомными) пространственно-временными масштабами, они относительно мало зависят от мн-

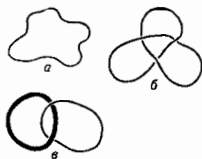


Рис. 3. Топологические типы кольцевых макромолекул: тривиальный узел (а), нетривиальный узел (б), нетривиальное заплетение (в).

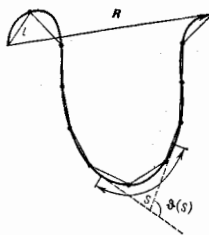


Рис. 4. К определению персистентной длины и эффективного сегмента.

системная длина \bar{l} и эффективный (или куновский) сегмент l . Персистентная длина \bar{l} определяется углом $\theta(s)$ между двумя участками макромолекулы (s — расстояние между ними вдоль цепи):

$$\langle \cos \theta(s) \rangle = \exp(-s/\bar{l}), \quad (1)$$

т. е. с ростом расстояния s усредненный косинус угла $\theta(s)$ экспоненциально убывает, \bar{l} — характерная длина этого убывания. На участке полимерной цепи короче \bar{l} гибкость практически не проявляется, т. е. такой участок является практически жестким [при $s \ll \bar{l}$ угол $\theta(s) \approx 0$]. На участках длиной $s \gg \bar{l}$ память о направлении цепи утрачивается, т. е. такие участки по направлениям статистически независимы [$\langle \cos \theta(s) \rangle \approx 0$], т. е. $\theta(s)$ с равной вероятностью принимает любые значения.

Куновский сегмент l определяется ф-той

$$\langle R^2 \rangle = Ll, \quad (2)$$

где L — полная контурная длина полимерной цепи, $\langle R^2 \rangle$ — среднеквадратичное значение вектора R , соединяющего концы полимерной цепи (рис. 4). Ф-ла (2) показывает, что полимерную цепь можно представить системой свободно сочлененных друг с другом эффективных жестких сегментов длины l , число таких сегментов в цепи равно L/l .

Осп. механизмы гибкости полимерной цепи — персистентный и поворотно-изомерный; первый осуществляется за счёт изгибов деформаций (прям. деформаций валентных углов), второй — за счёт поворотов мономерных звеньев вокруг соединяющих их ковалентных σ -связей. Если механизм гибкости цепи персистентный и угругость её однородно распределена вдоль контура, то $l = 2\bar{l}$, потому что «память» о направлении простирается от данной точки на расстояние \bar{l} в двух направлениях цепи (для др. цепей отношение l/\bar{l} численно также близко к 2).

Поворотно-изомерный механизм гибкости описывается количественно в рамках представления о дискретном наборе поворотно-изомерных состояний каждой связи между звеньями путём сведения к одномерной модели статистической физики (типа *Изинга модели*). Реально существуют как гибкоцепные макромолекулы (рис. 5, а), существенно изгибающиеся на длинах порядка неск. мономерных звеньев (для них $l \sim 1 \div 2$ нм), так и жесткоцепные (рис. 5, б), у к-рых изгибы становятся заметными лишь на значительно больших масштабах (напр. для двойной спирали ДНК $l \approx 100$ нм). Для жесткоцепных макромолекул реальна и такая ситуация, когда полная контурная длина меньше афф. сегмента; в таких макромолекулах

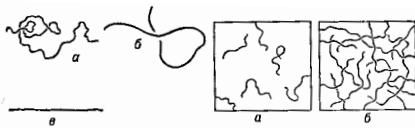


Рис. 5. Гибкоцепная (а), жесткоцепная (б) и стержнеобразная (в) макромолекулы.

Рис. 6. Сравнительная плотность макромолекул в разбавленном (а) и полуразбавленном (б) полимерных растворах.

гибкость почти не проявляется и они выглядят как практически жесткие стержни (рис. 5, в).

Ф-лы (1) и (2) справедливы только для идеальных макромолекул, т. е. таких, в к-рых мономерные звенья взаимодействуют только друг с другом вдоль полимерной цепи и отсутствуют т. н. объёмные взаимодействия (возможно, опосредованные окружающим макромолекулу веществом) между дальними по цепи звеньями, сближающимися при изгибах макромолекулы.

Конформация одиночной полимерной цепи. Конформация идеальной макромолекулы (см. *Конформации молекул*) на масштабе длины, больших l , аналогична траектории случайного броуновского блуждания частицы (рис. 4); сегмент (l) играет в этом случае роль длины свободного пробега частицы. Среднеквадратичное расстояние R между концами такой траектории пропорционально корню квадратному из числа сегментов: $R \propto \sqrt{L(l/l)}$, что соответствует (2). Макромолекула в такой конформации наз. гауссовым клубком (распределение вероятностей расстояния между её концами описывается *Гаусса распределением*).

Конформация реальной макромолекулы существенно зависит от характера объёмных взаимодействий. Если объёмные взаимодействия сводятся к взаимному отталкиванию сближающихся звеньев (или эффекту исключённого объёма — запрету для др. звеньев попадать внутрь данного звена), то макромолекула оказывается в состоянии набухшего клубка с размером R , пропорциональным lN^{ν} , где $\nu \approx 3/5$ — критич. показатель. Набухший клубок является сильнофлуктуирующей системой, его характеристика — показатель ν — обладает свойством универсальности, т. е. не зависит от деталей хим. структуры, подобно критич. показателям *фазового перехода* 2-го рода.

В том случае, когда объёмные взаимодействия определяются в осн. притяжением между звеньями, макромолекула «конденсируется» сама на себя и принимает конформацию т. н. глобулы. В отличие от клубка (гауссова или набухшего), в объёме к-рого ср. концентрация звеньев очень мала и стремится к нулю при $N \rightarrow \infty$, глобула представляет собой более компактную и плотную систему, концентрация звеньев в ней не зависит от N . Однако основное принципиальное качественное различие этих конформаций заключается в характере флуктуац. подвижности их элементов: в клубке радиус корреляции порядка размеров системы, т. е. флуктуации затрагивают весь клубок как целое; в глобуле же он много меньше размера системы, флуктуации имеют локальный характер и происходят в разных частях глобулы независимо.

Внутр. структура полимерной глобулы может быть аналогична структуре любой конденсиров. системы — жидкости, кристаллич. или аморфного твёрдого тела, жидкого или пластического кристалла, однородного или разбавленного раствора, стекла и т. п. Фундам. пример П. в глобулярном состоянии — глобулярные белки. При изменении внеш. условий конформация полимерной цепи может меняться от клубковой к глобулярной и обратно, соответствующий переход клубок — глобула является фазовым переходом типа конденсации.

Полимерные растворы. Состояние раствора П. в низкомолекулярном растворителе определяется концентрацией, температурой и составом растворителя. Фундаментальными для таких растворов являются понятия термодинамики, качества растворителя и понятие т. н. θ -точки. Содержание этих понятий связано с характером объемных взаимодействий. В полимерном клубке вследствие его высокой плотности доминируют шарные столкновения звеньев. Эти столкновения, как и в теории реальных газов (или растворов), характеризуются т. н. 2-м виральным коэффициентом, в виральном равновесии у-рии состоянии. Если 2-й виральный коэф. взаимодействия звеньев в данном растворителе положителен, то растворитель наз. хорошим, если отрицателен — плохим; если он равен нулю, растворитель наз. θ -растворителем. При изменении температуры или состава растворителя его качество для данного П. может меняться. Простой растворитель является хорошим при относительно высокой температуре, плохим — при низкой, θ -растворителем — вблизи определенной температуры (θ -точки и Флорн). В некоторых более сложных системах зависимость качества растворителя от температуры может быть как обращенной, так и немонотонной, с несколькими θ -точками.

В разбавленном полимерном растворе индивидуальные макромолекулы могут иметь конформации набухших клубков — в хорошем растворителе, гауссовых клубков — вблизи θ -условий, глобул — в плохом растворителе. По мере повышения концентрации полимерного раствора макромолекулы начинают взаимодействовать между собой. В условиях плохого растворителя это приводит к фазовому расслоению раствора (выпадению осадка), причём концентрация разбавленной фазы из-за низкой трансляц. энтропии оказывается чрезвычайно низкой. В хорошем или θ -растворителе ср. концентрация мономерных звеньев внутри отд. клубка очень мала, поэтому при повышении концентрации полимерного раствора перенутывание макромолекулярных цепей происходит уже при весьма малой концентрации П. в растворе (рис. 6). Т. о., для однородных полимерных растворов существует обширная область концентраций, в которой, с одной стороны, цепи сильно перенутываются, а с другой стороны, цепь занимает доля, занимаемая П. в растворе, ещё очень мала; полимерный раствор в этой области концентрации наз. *о д у р а з б а в л е н н ы м*. Существование полуразбавленного режима характерно именно для раствора длинных полимерных цепей.

Разбавленный и полуразбавленный растворы в хорошем растворителе являются сильнофлукутуирующими системами с дальними (создаваемыми цепями) корреляциями, существует количество, аналогия их свойств со свойствами систем (напр., магнитных) вблизи точек фазовых переходов 2-го рода (т. н. аналогия полемер — магнетик). Для описания сильнофлукутуирующих полимерных систем применяются теория флукутуаций и концепция скейлинга (*масштабной инвариантности*), заимствованная из теории критических явлений (см. *Фазовый переход*).

При дальнейшем концентрировании полимерного раствора объёмные взаимодействия становятся всё более существенными. Если кучовский сегмент макромолекулы существенно превышает их толщину, то ещё в полуразбавленном растворе П. эти взаимодействия приводят к фазовому переходу в ориентационно-упорядоченное, т. е. жидкокристаллическое, состояние. Такой полимерный *жидкий кристалл* наз. *диотропным*; он содержит большое кол-во растворителя, и его свойствам проще всего управлять, изменяя состав или кол-во растворителя.

Полимерный раствор, в котором объёмная доля растворителя так мала, что объёмные взаимодействия не сводятся к шарным или тройным столкновениям, а имеют существенно многочастичный характер, наз. концентри-

рованными. В пределе полного отсутствия растворителя получается чистое полимерное вещество.

В фазо-однородном полуразбавленном или концентрированном полимерном растворе или чистом полимерном веществе длинные цепи имеют конформации гауссовых клубков благодаря тому, что объёмные взаимодействия, будучи очень сильными на расстояниях порядка размера одного звена, тем не менее экранируются на больших расстояниях. Причина экранировки, уменьшающей виральный коэф. взаимодействия в N раз, связана с N -кратным уменьшением трансляц. энтропии при объединении звеньев в одну цепь.

Макроскопические фазовые состояния полимерного вещества. Газообразное состояние для полимеров не характерно, необходимо для его реализации давление экспоненциально убывает с длиной цепей. Реально отдельные слабо взаимодействующие друг с другом макромолекулы могут наблюдаться только в разбавленном полимерном растворе. В конденсированных же состояниях (концентрированный полимерный раствор или чистое полимерное вещество), в зависимости от характера и силы взаимодействий звеньев, П. может пребывать в одном из четырёх макроскопических фазовых состояний: вязкотекучем, высокоэластичном, стеклообразном и кристаллическом. Полимерная жидкость в вязкотекучем состоянии наз. также *полимерным расплавом*.

Текучесть такой жидкости обусловлена тем, что она состоит из ковалентно не связанных (т. е. не образующих полимерную сетку) цепных макромолекул; чрезвычайно высокая вязкость полимерного расплава связана с тем, что возможность движения каждой макромолекулы в системе сильноперенутанных цепей очень сильно ограничена запретом на прохождение участков цепей друг сквозь друга. Единств. механизм крупномасштабного движения макромолекул в системе сильноперенутанных цепей — диффузионное проползание макромолекулы вдоль эфф. трубки, создаваемой участками окружающих цепей (т. н. *рептация*; рис. 7).

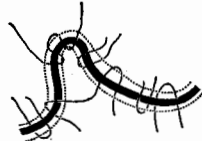


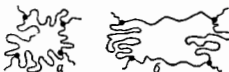
Рис. 7. Эффективная трубка, вдоль которой происходит диффузионное движение типа рептации.

Рептационный механизм движения обуславливает не только большую величину вязкости полимерного расплава, но и присущее ему свойство вакуоупругости: при увеличении частоты внеш. воздействия отклик полимерного расплава меняется от вязкого к упругому, причём частота изменения характера отклика $\sim N^{-3,4}$, т. е. весьма резко падает с ростом N . Особенно медленные рептации для систем разветвленных макромолекул, где соответствующая частота экспоненциально убывает с ростом N .

Упругое поведение полимерного расплава сходно с поведением высокоэластического полимерного тела. Свойство высокоэластичности состоит в способности тела претерпевать огромные деформации (до мм. сотен процентов) упруго (т. е. с восстановлением исходных размеров и формы после снятия напряжения) при нелинейной зависимости деформации от напряжения. Высокоэластич. состояние характерно для сетчатых П. (полимерных гелей). К ним относятся: полимерная сетка, состоящая из ковалентно соединённых друг с другом линейных полимерных цепей; т. н. физ. гель, в котором межцепные сшивки осуществляются более слабыми, чем ковалентные, связями (водородными, дисоль-дипольными, ионными и т. п., а также густаксия более плотной, напр. кристаллической, фазы и др.).

Природа высокоэластичности П. связана с тем, что участки полимерных цепей между соседними сшивками представляют собой свёрнутые в пространстве клубки (рис. 8, а); весьма значит. деформация тела может осуществляться в результате некоего распрямления цепочек (рис. 8, б).

Рис. 8. Свободная (а) и деформированная (б) полимерные сетки; вытягивание цепей для наглядности сильно преувеличено.



Для мя. П. характерны анизотропия формы сегментов макромолекул и анизотропия объёмных взаимодействий; расславы, концентров. растворы или гели таких П. образуют нематические, холестерические или смектические жидкие кристаллы. Они неаэ. термотропны, потому что управлять появлением или исчезновением жидкокристаллич. структуры и её параметрами проще всего изменением темп-ры.

Стеклообразное состояние П. в целом аналогично состоянию обычных низкомолекулярных стёкол, однако стеклование для П. более типично, чем для обычных низкомолекулярных веществ, т. к. вследствие топологии, ограничивающей релаксац. процессы в П. затормаживаются и П. «замораживаются». Особенно склонны к стеклованию П. из разветвлённых макромолекул. Большинство пластмасс и смол представляют собой полимерные стёкла.

Кристаллич. состояние П. во многом сходно с кристаллич. состоянием низкомолекулярных веществ, однако его образование в П. осложняется из-за большой длины макромолекул, и, как правило, кристаллизующиеся П. образуют лишь частично кристаллич. фазу, в к-рой кристаллич. области разделены обширными аморфными прослойками с перепутанными цепями.

Фазовые расщепления и доменные структуры в полимерах. В плохо растворителе выпадает осадок, т. е. происходит расщепление раствора на концентрированную и разбавленную фазы. Концентрация П. в разбавленной фазе может оказаться чрезвычайно низкой и при недостаточной чувствительности методов регистрации разбавленная фаза предстаёт как практически чистый растворитель. В смесях двух или нескольких разных полимерных веществ, как правило, возникает сегрегация на практически чистые компоненты. П. очень плохо смешиваются друг с другом: из-за низкой трансляц. энтропии цепей даже при слабом отталкивании мономерных звеньев смесь расслаивается на почти чистые фазы.

Особый тип фазового расщепления — микрофазное расщепление, или образование доменной структуры, наблюдается в расплавах или концентров. растворах блоксополимеров с плохо смешивающимися блоками. Истинное расщепление на макроскопич. фазы в такой системе невозможно, т. к. блоки соединены в единые цепи. Блоки из мономерных звеньев одного из сортов образуют поэтому либо шаровые или цилиндрич. домены (мицеллы), либо чередующиеся плоские слои (ламельлы). Аналогичные микродоменные структуры образуют также системы дифильных молекул — полимерных цепей с хим. группой на конце, отталкивающейся от мономерных звеньев (напр., водные растворы фосфолипидов, молекулы к-рых включают гидрофобный полимерный «хвост» и гидрофильную «голову»).

Динамика полимеров. Кроме мелкомасштабных движений звеньев, длинным цепным молекулам присущи движения в масштабе всей цепи. Соответствующее макс. время релаксации растёт с длиной цепи $\sim N^2$, причём значение τ зависит от характера объёмных взаимодействий, от гидродинамики окружающей среды и др., но всегда $1,5 < \tau < 3,5$.

В жидкой среде полимерная глобула и полимерный клубок обладают свойством неперетеккости: коэф. диффузии клубка как целого по порядку величины сов-

падает с коэф. диффузии сплошного шара с тем же радиусом инерции. Типичным механизмом подвижности полимерных цепей в концентров. системах, где существенны топологич. ограничения, являются рептации (рис. 7).

Синтез полимеров. Линейные цепные молекулы образуются в результате процессов полимеризации и (последоват. присоединения мономеров к растущей цепи по схеме $AN + A_1 \rightarrow AN_{21}$) либо поликонденсации и (постепенного обединения участков цепи со свободными валентностями на концах по схеме $AN + AM \rightarrow AN_{2M}$). Рост цепи заканчивается при присоединении к концу макромолекулы одновалентного соединения или (для полимеризации) при исчерпании мономера.

Если при синтезе полимерной цепи присутствуют не только мономеры с двумя функциональными группами (т. е. группами, способными установить валентные связи с др. мономерами), но и соединения с тремя или большим числом таких групп, то в результате получаются разветвлённые макромолекулы (рис. 2). В присутствии мономеров разных сортов получают макромолекулы гетерополимеров.

Получающаяся при синтезе полимерная система оказывается полидисперсной, т. е. содержит цепочки разных длин; характер полидисперсности определяется т. н. молекулярно-массовым распределением (или распределением по длинам цепей). Системы разветвлённых макромолекул обычно полидисперсны также по степени и характеру разветвлённости. Кроме того, макромолекулярные цепочки гетерополимеров отличаются друг от друга последовательностью расположения звеньев разных типов вдоль цепи (первичными структурами).

Биол. полимеры не обладают полидисперсностью: все однотипные макромолекулы, синтезирующиеся в живой клетке, одинаковы по длине и имеют одинаковую первичную структуру.

Полимерная сетка образуется в результате полимерного синтеза в присутствии би-, три- или мультифункциональных мономеров или при сшивании линейных цепей. В первом случае концентрация мономеров в исходной смеси должна превышать нек-рую величину, наз. порогом гелеобразования, для того чтобы наряду с разветвлёнными макромолекулами конечных размеров, получаемыми при низкой концентрации смеси, в системе возник т. н. бесконечный кластер, т. е. макроскопич. сетка (его возникновение аналогично процессу перколяции). Во втором случае сшивание предварительно синтезированных линейных цепей, находящихся в состоянии полимерного расплава или концентров. полимерного раствора, может быть осуществлено бивалентными хим. сшивками или ионизирующим облучением. Такой процесс наз. в у л к а и н з а ц и я и й. Первая высокоэластическая резина была получена вулканизацией натурального каучука: сшиванием цепей натурального каучука двухвалентными атомами серы.

Лит.: Флор П. J., Principles of polymer chemistry, Ithaca, 1953; Волькенштейн М. В., Конфигурационная статистика полимерных цепей, М.—Л., 1958; Б р и н т з и я н М. М., П е т з и н О. Б., Конформация макромолекул, М., 1964; Г е н ф о р д Ч., Физическая химия полимеров, пер. с англ., М., 1965; Ф л о р и П., Статистическая механика цепных молекул, пер. с англ., М., 1971; Ж е н П. Ж., де Иди сфелитца в физике полимеров, пер. с англ., М., 1982; Г о с т д и б Ю. И., Д а р и н с к и й А. А., С в е т л о в Ю. Е., Физическая кинетика макромолекул, Л., 1986; Д а ш е в с к и й В. Г., Конформационный анализ макромолекул, М., 1987; Р о з е н б е р г В. А., Степенное полимериз., 1987; Г р о с с б е р г А. Ю., Х о х л о в А. Р., Статистическая физика макромолекул, М., 1988.

А. Ю. Гроссберг.

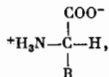
ПОЛИМЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ (биополимеры) — природные макромолекулы, играющие осн. роль в биол. процессах. К П. Б. относятся белки, нуклеиновые кислоты (НК) и полисахариды. П. Б. образуют структурную основу всех живых организмов; все процессы в клетке связаны с взаимодействиями П. Б. между собой

и с др. молекулами. Среди последних важную роль играют липиды, образующие биол. мембраны (см. *Клеточные структуры*). Липиды не являются полимерами, но обладают нек-рыми общими с ними свойствами, в частности способностью образовывать жидкокристаллич. структуры.

П. б. являются высокомолекулярными соединениями (моп. масса 10^3 — 10^{10} а. е. м.), к ним приложимы все закономерности, установленные для др. природных и синтетич. полимеров. Однако особенности хим. строения приводит к появлению у П. б. уникальной пространств. структуры, необычных физ., хим. и биол. свойств. По строению осн. цепи белки и НК однородны, подобно о м о п о л и м е р а м, у к-рых все мономерные звенья цепи идентичны. Но в последовательности боковых групп у П. б. закодирована генетич. информация организма, поэтому П. б. следует отнести к г е т е р о п о л и м е р а м с заданной нерегулярной последовательностью мономерных звеньев. В структуре и свойствах П. б. отражены эти особенности их хим. строения. Пространств. строение П. б. с определ. структурой всей макромолекулы наз. к о н ф о р м а ц и е й; от конформации зависит взаимодействие П. б. с др. молекулами. Наиб. важные биол. ф-ции П. б. также определяются его конформацией и способностью изменять её при разл. взаимодействиях. В большинстве случаев взаимодействия П. б. являются специфическими, т. е. зависят от последовательности мономерных звеньев и локальной структуры (см. также *Биофизика*).

Различают 4 уровня структурной организации П. б. Наиб. отчетливо они выражены у белков. П е р в и ч н а я структура — это хим. строение молекулы. Чаще всего под первичной структурой понимают последовательность мономерных звеньев П. б. В первичную структуру включают хим. связи между цепями и внутри цепей (между отд. звеньями). В т р и ч н а я структура — спиральное расположение мономерных звеньев в тех или иных участках цепи П. б. Т р е т ь я структура — пространств. структура цепи, включая расположение элементов вторичной структуры и связывающих их участков. Ч е т в е р т и ч н а я структура — расположение отд. цепей (единиц третичной структуры) в образуемом ими комплексе.

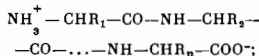
Белки состоят на одной или неск. полипептидных цепей, к-рые соединены между собой хим. или межмолекулярными связями. Полипептидные цепи построены из мономерных звеньев — аминокислотных остатков 20 разл. сортов. Аминокислоты представляют собой орган. (карбоновые) кислоты, содержащие 1 или 2 аминогруппы NH_2 . В нейтральной среде они имеют структуру,



где R — боковая группа, своя для каждой из 20 аминокислот. Аминокислоты являются оптич. L-изомерами (см. *Изомерия молекул*). Число мономерных звеньев, входящих в полипептидные цепи, может изменяться от неск. десятков до неск. тысяч; полипептиды с меньшим числом звеньев наз. о л и г о п е п т и д а м и. Каждый белок имеет определ. размеры (моп. масса $\geq 5 \cdot 10^3$), его индивидуальность определяется последовательностью аминокислотных остатков. По своим ф-циям белки делится на каталитические (ферменты, биол. катализаторы хим. реакций), структурные, транспортные (гемоглобин), рецепторные, регуляторные (гормоны), защитные (антитела) и др. В зависимости от состава выделяют простые белки — п р о т е и н ы, состоящие только из аминокислот, и сложные белки — с о с т о я т е л ь н ы е, в состав к-рых входят с аминокислотами входят углеводы (гликопротеиды),

липиды (липопротеиды), НК (нуклеопротеиды) и т. д. По форме различают глобулярные белки, образующие плотные глобулы, и фибриллярные белки, образующие длинные волокна или слои. Белки участвуют в важнейших генетич. и регуляторных процессах. Нек-рые структурные белки могут образовывать агрегаты в виде волокон, трубочек, оболочек. Иногда один и тот же белок выполняет неск. ф-ций.

П е р в и ч н а я структура. Образование полипептидной цепи с заданной последовательностью аминокислотных остатков происходит в клетке внутри клеточного аппарата — рибосомы. Присоединение каждого последующего звена цепи происходит с выделением молекулы воды. Образующаяся цепь имеет следующую структуру:



поскольку соединение мономеров происходит по принципу «головка к хвосту», цепь имеет определен. направление: слева находится N-конец цепи, справа — C-конец. Аминокислотные остатки цепи в зависимости от вида боковой группы R делятся на неск. типов. К неполярным, плохо растворяющимся в воде относятся аланин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, триптофан, тирозин, метионин, глицин и цистеин. Полярные и заряженные аминокислотные остатки обладают хорошей растворимостью в воде. К полярным относятся серин, треонин, аспаргин, пролин и глутамин. Заряжены аспаргиновая и глутаминовая к-ты (отрицательно), лизин и аргинин (положительно). Могут быть заряжеными также цистеин и тистидин. В целом молекула белка несёт зарядок, и отрицат. заряды. В первичной структуре белка заключена вся информация, определяющая его пространств. структуру и ф-ции. Определение первичной структуры полипептидной цепи производится путём частичного расщепления её на короткие перекрывающиеся фрагменты с последующим анализом их аминокислотной последовательности, начиная с N-конца. Это удается сделать для не слишком длинных последовательностей, поэтому структуру длинных полипептидов находят, комбинируя данные для фрагментов.

Полипептидная цепь обладает гибкостью за счёт вращения вокруг хим. связей, образуемых атомами C (чёрные шарики на рис. 1, вращение изображено стрел-



Рис. 1. Вращение пептидных групп.

ками). Связь между группами CO и NH наз. пептидной. Вращение вокруг пептидной связи затруднено, поэтому атомы N, N, C и O лежат в одной плоскости.

В т р и ч н а я структура. Благодаря своей гибкости полипептидные цепи способны образовывать упорядоченные структуры со спиральной симметрией. Наиболее распространены α -спирали и β -структуры. α -Спираль представляет собой правую спираль, у к-рой на один виток приходится 3,6 аминокислотных остатка; шаг спирали 5,4 Å, диаметр ~6 Å (без боковых групп). Спираль стабилизируется водородными связями между группами CO и NH разл. мономерных звеньев, отстоящих друг от друга на расстоянии 4 остатков. Водородные связи (пунктир на рис. 2,а) направлены вдоль оси спирали, в целом α -спираль представляет собой довольно жесткую структуру. Не всем аминокислотным остаткам энергетически выгодно образование

α -спирали. Знание соответствующих энергетич. параметров позволяет предсказывать вероятность образования α -спирали в том или ином участке белка. Существуют β -слой двух типов: параллельные и антипараллельные. На рис. 2.6 показана структура антипараллельного β -слоя. Стабилизирующие β -слой водородные

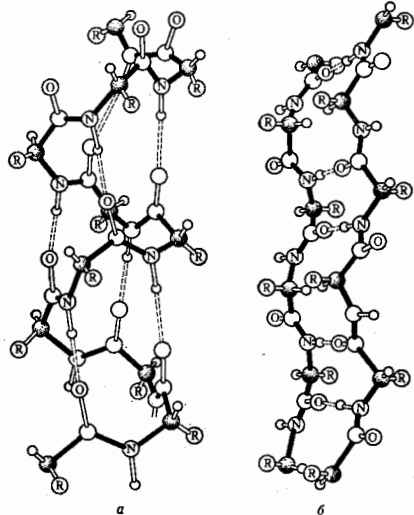


Рис. 2. Вторичная структура белков: а — α -спираль; б — β -структура.

связи между пептидными группами направлены поперёк цепи, а сами цепи вытянуты и образуют складчатую структуру. В белке встречаются также т. н. β -нагибы, обеспечивающие поворот цепи примерно на 180° при образовании водородной связи. Возможны и др. типы спиралей. Все названные вторичные структуры характерны для глобулярных белков. Фибриллярный белок, из к-рого строятся длинные ориентиров. волокна, образует спирали иного вида. Вторичную (и третичную) структуру белка исследуют с помощью рентгеновского структурного анализа, позволяющего определить положение всех атомов в молекуле. Трудности здесь связаны с тем, что не каждый белок можно получить в виде кристаллов необходимого размера. Обычно структура белка в растворе мало отличается от структуры в кристалле, это связано с тем, что кристаллы белка содержат много воды. Однако в целом вопрос о соответствии структуры белка в растворе и в кристалле остаётся открытым. Содержание α - и β -структур сильно различается для разл. белков.

Третичная структура. Большинство глобулярных белков находится в водно-солевой среде. Укладка элементов вторичной структуры при этом такова, что гидрофильные (полярные, заряженные) аминокислотные остатки располагаются в осн. на поверхности глобулы, а неполярные, плохо растворимые в воде (гидрофобные) аминокислотные остатки — во внутр. части глобулы. При этом глобула приобретает уникальную (идентичную для всех молекул данного белка) компактную и стабильную форму.

Чаще всего внутр. часть глобулы образована β -слоями, а наружная — α -спиралями. Установлена закономерность в аминокислотной последовательности в этих α -спиралях: каждое 3-е или 4-е положение вдоль цепи занимают неполярные аминокислотные остатки. При этом на боковой поверхности цилиндра, к-рым можно представить α -спираль, образуется неполярная полоса, параллельная её осн. Именно эта гидрофобная полоса обращена внутр. глобулы и контактирует с её гидрофобной частью.

Исключение составляют мембранные белки, контактирующие с неполярной жирной внутр. частью липидной мембраны. На поверхности белка в этом случае находятся гидрофобные аминокислотные остатки.

Ещё одна важная закономерность пространств. структур белков — доменная структура. Часто единая полипептидная цепь образует не одну глобулу, а неск. компактных областей, расположенных определ. образом в пространстве. Каждая такая область (домен) формируется из α -спиралей, β -слоёв и др. элементов вторичной структуры. В этом случае можно говорить как о третичной структуре таких доменов, так и о третичной структуре белков в целом, понимая под этим взаимное расположение доменов в пространстве. Примером домена, содержащегося во мн. белках, является блок из двух β -слоёв, соединённых между собой α -спиральным сегментом. Доменная структура белков важна для их биол. ф-ций. Вероятно также, что домены — это элементарные белки, на основе к-рых в ходе эволюции возникает разнообразие белковых структур.

Четвертичная структура. В тех случаях, когда глобулярный белок состоит из неск. субъединиц, не связанных между собой хим. связями, говорят о его четвертичной структуре. Связь субъединиц между собой осуществляется гл. обр. за счёт гидрофобных взаимодействий; при этом на контактирующих частях поверхности субъединиц расположены в осн. гидрофобные аминокислотные остатки. Иногда во взаимодействие между субъединицами глобулярных белков дают заметный вклад водородные связи. Др. тип четвертичных структур представляют белки, образующие виты цитоскелета. Цитоскелет заполняет пространство между ядром и внутр. поверхностью клеточной мембраны и выполняет ряд важных ф-ций, определяя форму клетки, её перемещение как целого, размещение и транспорт внутр. компонентов. Известны три типа таких витей: микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты. Подробно изучены первые два типа. Микрофиламенты собираются из молекул глобулярного белка актина, соединяясь в длинные цепи, образующие двойные спирали. Микротрубочки также собираются из глобулярных молекул белка тубулина и являются важным компонентом митотич. аппарата (аппарата деления) клетки, образующим т. н. митотич. веретено и определяющим распределение генетич. материала между дочерними клетками.

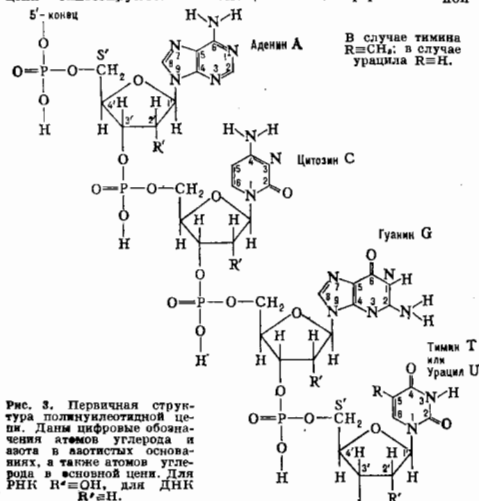
Особый тип структур представляют фибриллярные белки актин и миозин, образующие упорядоченные структуры (саркомеры). Их скопление друг относительно друга составляет основу механизма мышечного сокращения. В сложные пространств. структуры собираются белки оболочек вирусов, бактериофагов и таких структур, как рибосомы, нуклеосомы и др.

Высшие структуры белков — это состояния, обладающие относит. минимумом свободной энергии. Они устойчивы в физиологич. условиях, могут изменяться лишь в определ. пределах. Наиб. устойчива первичная структура белков, остальные легко разрушаются при внеш. воздействиях. Такое разрушение наз. денатурацией и, как правило, приводит к потере биол. свойств.

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) и рибонуклеиновые кислоты (РНК) являются полинуклеотидами, т. е. П. б.,

мономерными звеньями k -рых служат нуклеотиды. Нуклеотиды состоят из азотистого основания, остатков фосфорной k -ты и углевода (рибозы или дезоксирибозы). ДНК является хранителем генетич. информации организма, записанной в виде последовательности 4 сортов её мономерных звеньев. Эта информация переносится (транскрибируется) при синтезе иРНК (матричной) РНК (мРНК), а затем с помощью генетич. кода переводится (транслируется) в аминокислотную последовательность белков. Др. виды РНК выполняют роль переносчиков аминокислот (транспортные РНК — тРНК) и составляют структурную основу рибосом (рибосомные РНК — рРНК). Молекулы РНК в нек-рых случаях могут обладать также каталитич. активностью, подобной активности белков-ферментов (т. н. рибозимы).

Первичная структура НК. Полинуклеотидная цепь (рис. 3) состоит из сахарофосфатного остова (в него входят дезоксирибоза в случае ДНК и рибоза в случае РНК), к k -рому присоединены плоские боковые группы — азотистые основания (аденин A , цитозин C , гуанин G и тимин T в случае ДНК; A , C , G и урацил U в случае РНК). В клетке такие цепи синтезируются с помощью спец. ферментов



на матрице — молекула ДНК; существует и процесс синтеза ДНК на РНК-матрице, осуществляемый др. ферментом (обратной транскриптазой). Полинуклеотидная цепь имеет направление, определяемое тем, что 3'-й атом S одного мономера соединяется фосфоэфирной связью с 5'-м атомом S следующего мономера. Каждая мономерная группа цепь ионизована и несёт один отрицат. заряд. Размеры молекул РНК и ДНК изменяются в широких пределах. Транспортные РНК (самые короткие молекулы РНК) состоят из 75—84 нуклеотидов; длина гетерогенных ядерных РНК достигает $2 \cdot 10^6$ нуклеотидов. Короткие ДНК содержат обычно нек. тысяч пар нуклеотидов, но существуют ДНК, k -рые содержат аж 10^6 .

Вторичная структура ДНК. Осн. принцип образования вторичных структур полинуклеотидов — т. н. комплементарное спаривание азотистых оснований.

Оно приводит к образованию двойных и тройных витковых структур (спиралей), стабилизируемых водородными связями между азотистыми основаниями разных цепей и межкислотостными взаимодействиями азотистых оснований. Осн. вторичная структура ДНК (B -форма), представляющая собой правую двойную спираль, предложена в 1953 Дж. Уотсоном (J. Watson) и Ф. Криком (F. Crick). В этой структуре две комплементарные цепочки антипараллельны. Против каждого A одной цепи расположено T другой, против G расположено C (в двуветвевой РНК A спаривается с U). При этом образуются энергетически выгодные водородные связи: 2 в A -паре и 3 в G -паре; расстояние между точками присоединения оснований к сахарам оказывается одинаковым для A - T - и G - C -пар (рис. 4). Сахарофосфатные цепи образуют при этом гладкие витковые линии. Плоскости оснований в B -форме ДНК составляют с осью двойной спирали прямой угол. На виток двойной спирали приходится в натривой соли ДНК при высокой влажности 10 пар оснований. Расстояние между плоскостями соседних пар оснований составляет 3,4 Å , что оптимально для межкислотостных взаимодействий, вносящих наиб. энергетич. вклад в стабильность двойной спирали. В растворе на виток двойной спирали в B -форме приходится 10,5 пары оснований. Диаметр двойной спирали равен примерно 22 Å . B -форма характерна для натривой соли ДНК. При изменении внеш. условий (темпер., ионного состава среды) параметры двойной спирали в B -форме изменяются, поэтому следует говорить о B -семействе структур. К этому семейству относятся и литиевая соль ДНК, т. н. C -форма, в k -рой на виток двойной спирали приходится 9,3 пары оснований, плоскость оснований отклонена на 6° от плоскости, перпендикулярной к оси спирали.

В натривой соли ДНК при относит. влажности ниже 75% происходит кооперативный реакц. переход ДНК из B - в A -форму. A -форма (точнее A -семейство форм) — это также правая двойная спираль, но с др. параметрами, чем у B -формы. Плоскости оснований сильно отклонены от плоскости, перпендикулярной к оси спирали, а сами пары комплементарных оснований смещены от оси двойной спирали к её периферии, поэтому при наблюдении вдоль оси молекула в A -форме представляется полой трубкой. РНК существует только в A -форме, как и гибриды ДНК — РНК. Характерная для двуветвевой РНК структура содержит 11 пар оснований на виток двойной спирали, а отклонение плоскости оснований от плоскости, перпендикулярной к оси, составляет 10—14°. B -форма — осн. структура ДНК в живой клетке. ДНК может существовать и в др. форме, в виде Z -спирали. Рентгеноструктурный анализ позволил, как и в случае белков, установить с высоким разрешением

пространств. структуры полинуклеотидов с разл. последовательностями нуклеотидов. Z -форма ДНК, получившая своё назв. в связи с зигзагообразным строением сахарофосфатного остова, представляет собой левую двойную спираль с периодом 44,6 Å , содержащую 12 пар оснований на виток и образованную антипараллельными полинуклеотидными цепями, спарившимися по правилам комплементарности. Повторяющимся звеном в ней является не одна пара нуклеотидов, а две. Набл. легко в Z -форму переходят регулярно чередующиеся последовательности пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. В физиологич. условиях Z -форма в линейных ДНК не наблюдается. Однако в кольцевых молекулах ДНК может происходить переход отд. участков молекулы в Z -форму. На рис. 5 приведены объёмные модели ДНК в B - и Z -формах.

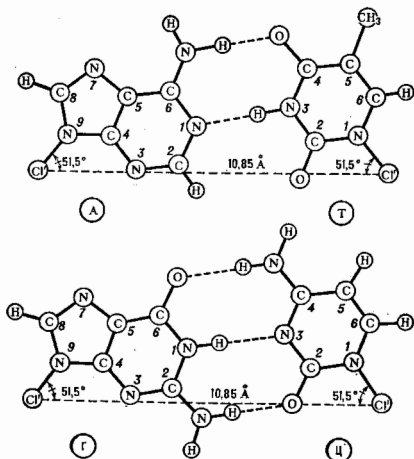


Рис. 4. Уотсон-криковские пары оснований (жирным пунктиром обозначены водородные связи).

Двойная спираль ДНК в В-форме является сравнительно жёсткой молекулой. Её макромолекулярные свойства в растворе хорошо описываются моделью гибкого упругого стержня, совершенного теплового движения. Изгибная жёсткость ДНК в А-форме больше, чем в В-форме, причём она анизотропна: молекула в каждой точке легче изгибается в направлении желобов двойной спирали, чем в перпендикулярном направлении.

Вторичная и третичная структуры РНК. Молекулы РНК встречаются преимущественно в виде одиночных нитей, в которых образуются дуплетные шпильки за счёт спаривания оснований комплементарных участков нити. Однонитевые участки могут образовывать водородные связи с др. одиночными участками, определяя третичную структуру молекулы. Третичная структура хорошо изучена для молекулы тРНК; если по вторичной структуре тРНК напоминает клеверный лист, то в пространстве она принимает форму буквы Г. Вторичная структура фенилаланиновой тРНК, близкая к А-форме, содержит 20 пар оснований, между к-рными образованы 52 водородные связи. Третичная структура содержит ещё неск. дес. таких связей с участием азотистых оснований и сахарофосфатных цепей. Все виды тРНК имеют сходную третичную структуру.

Третичная структура ДНК. В вирусных частях ДНК компактно упакована, однако данные о виде этой упаковки отсутствуют. Лучше известна упаковка ДНК в хромосомах эукариотич. клеток (см. *Клеточные структуры*). ДНК вирусов, бактериофагов, плазмид и бактерий обычно представляют собой кольца, образованные замкнутыми двойными спиральми (каждая из нитей замкнута на себя). Хромосомная ДНК в эукариотич. клетках также образует петли, топологически эквивалентные замкнутым кольцам. Кольцевая ДНК обычно сверхспирализована и образует пространств. сверхвитки, к-рые также можно рассматривать как элементы третичной структуры ДНК. В разл. условиях и в зависимости от последовательности нуклеотидов, ДНК может образовывать и др. виды вторичной и третичной структур (параллельные спирали, тройные и четвертные спирали и др.).

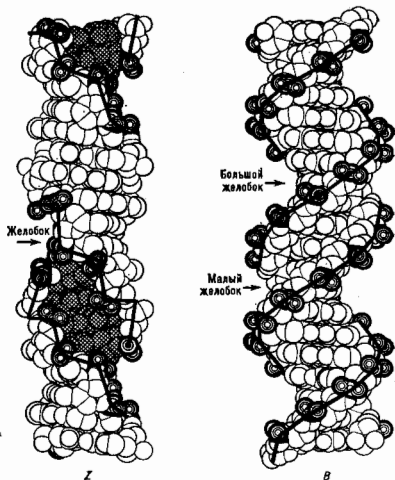


Рис. 5. Объёмные модели ДНК в В- и Z-формах (жирной линией обозначен сахарофосфатный остов).

Полисахариды являются П. б., построенными из моносахаридных остатков. Примерами линейных гомополисахаридов являются амилоза (составная часть крахмала) и целлюлоза (осн. часть древесины). Мономером амилозы и целлюлозы является глюкоза. Др. пример линейного гомополисахарида — хитин, из к-рого построены панцири насекомых. Мономерным звеном линейного полисахарида может быть и дисахарид. Первичная структура полисахарида, как правило, регулярна, но существуют полисахариды с нерегулярной последовательностью разл. мономерных звеньев. Помимо линейных существуют полисахариды с разветвлённой первичной структурой. Линейные полисахариды образуют жёсткие вторичные структуры (одно-, двух- и трёхнитевые спирали). Более высокие структуры могут быть как волокнистыми, так и гелеобразными. Если однородность полисахаридной цепи нарушена встраиванием др. сахаридов или ветвлениями, полисахариды могут образовывать гибкие волокна или гели. Полисахариды могут образовывать комплексы с белками и липидами, они придают жёсткость и прочность стенкам клеток растений и бактерий. Стенки животной клетки не обладают этими св-вами и содержат в клеточной мембране лишь нек-рое кол-во олигосахаридов (коротких полисахаридов), связанных с белками, т. е. гликопротеидами.

Исследование структуры и свойств П. б. производят разл. физ. и физ.-хим. методами. Сюда относятся рентгеноструктурный анализ и электронная микроскопия, метод ИМР в ЭПР, диффузное рассеяние рентг. лучей, оптич. методы (исследование спектров поглощения, оптич. активности, люминесценции и др.), микрокалориметрия, гидродинамич. методы, хромография, электрофорез, полярография и др. Изучение фотохим. и радиац.-хим. изменений в П. б. служит для исследования их структуры и для исследования механизма действия УФ- и ионизирующего излучения на эти объекты. П. б. являются диэлектриками и полидиэлектритами, поэтому важны измерения диэлект-

рич. поляризации и потерь в широком диапазоне частот. Особый интерес представляет исследование конформ. превращений П. б. в растворе, с этой целью используют спектрофотометрию в УФ-области и измерения кругового дихроизма. В полнпептидах при образовании из беспорядочного клубка упорядоченной спиральной структуры в области длин волн ~ 190 нм наблюдается сильный гипохромный эффект (уменьшение поглощения), пригодный для определения степени спиральности. Ароматические аминокислотные остатки имеют полосы поглощения в области ~ 280 нм, изменяющиеся при изменении окружения (неполярного на полярное), что позволяет судить о расположении и контактах этих остатков в молекуле белка. Межплоскостные взаимодействия в НК обуславливают гипохромный эффект в области ~ 260 нм. Соответственно при разрушении двойной спирали (переход спираль — клубок) наблюдается увеличение поглощения на 40%. Приrost поглощения пропорционален доле нуклеотидов, перешедших из упорядоченной спиральной структуры в неупорядоченный клубок. П. б. обладают оптич. активностью, свойственной всем аминокислотам (кроме глицина) и, соответственно, полнпептидам и белкам. Наб. информативны измерения кругового дихроизма, к-рый зависит от конформации полимера. На рис. 6 приведены кри-

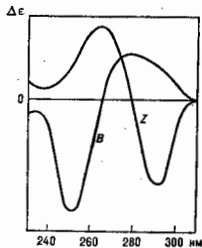


Рис. 6. Спектры кругового дихроизма ДНК в B- и Z-формах.

вые кругового дихроизма для ДНК в B- и Z-формах.

Переходы спираль — клубок в П. б. Полнпептидные цепи, образующие в определ. условиях упорядоченные спиральные структуры, при изменении внеш. условий переходят в состояние неупорядоченного клубка. Эти конформ. переходы наб. детально изучены на синтетич. гомогенных полнпептидах. Переход α -спираль — клубок носит кооперативный характер и характеризует сравнительно узким интервалом перехода. Кооперативность перехода обусловлена невыгодностью объединения из спиральной структуры (плавания) коротких участков, т. к. при этом затрачивается значит. энергия на разрыв водородных связей, а выигрыш в энтропии за счет появления подвижности пептидных звеньев мал. При плавлении длинных участков спирала возможна компенсация энергетич. затрат. Процесс денатурации белков при изменении внеш. условий включает в себя и переход спираль — клубок, но обычно процесс является многостадийным. Отд. стадии могут носить кооперативный характер. Изучение промежуточных стадий и кинетики прямого и обратного процессов (ренатурации) является источником сведений о самоорганизации высших структур белковых глобул. Двойная спираль ДНК может разрушаться при изменении внеш. условий, молекула при этом переходит в состояние одного или двух беспорядочных клубков (при полном разделении нитей). Этот переход, также как, переходом спираль — клубок или внутримолекулярным плавлением, изучен экспериментально и теоретически для B-форм ДНК. Переход спираль — клубок рассматривают на основе одномерной *Изинга модели*.

В рамках модели объясняются все наблюдения на опыте закономерности перехода в ДНК. Переход спираль — клубок в ДНК аналогичен фазовому переходу 1-го рода, но не является истинным фазовым переходом, т. к. молекулу можно рассматривать как одномерную систему. Интервал перехода (напр., интервал темп-р перехода) конечен. В этом интервале молекула разбивается на чередующиеся спиральные и клубкообразные участки. Т. к. локальное или полное разделение нитей двойной спирали ДНК происходит при мн. генетич. процессах в клетке, причём в этом процессе участвуют др. молекулы, взаимодействующие с ДНК, теория перехода спираль — клубок, включающая вопрос о влиянии др. молекул (теория скрепок), важна для понимания механизма функционирования ДНК.

ДНК в клетке обладает отриц. сверхспиральностью и за счёт её, т. е. двойная спираль в ней несколько раскручена (в колцевых ДНК при этом двойная спираль образует витки сверхспирали). В клетке есть система ферментов (топизомераз), изменяющих сверхспиральность. Широко распространена лишь отриц. сверхспиральность. Сверхспиральная ДНК обладает повыш. энергией; топизомеразы расходуют энергию на создание сверхспиральности. Мерой сверхспиральности является плотность сверхвитков (число сверхвитков, приходится на один виток двойной спирали). Величина σ отрицательна, ниже подразумевается её абс. значение. С ростом σ молекула ДНК становится более подвижной, реакционноспособной, увеличивается вероятность нарушения структуры двойной спирали (локальных её раскрутий), в отд. областях молекулы при достаточном большом значении σ возникают альтернативные (т. е. отличные от B-формы) структуры — крестообразные структуры, Z- и H-формы и др. Все эти структуры не образуются в линейной ДНК в стандартных условиях. Энергия, необходимая для их образования, черпается из энергии сверхспиральности. Для исследования альтернативных структур ДНК и определения их энергетич. параметров используют эксперимент, анализируемые с помощью топологич. теории. Топологич. ограничения, накладываемые кольцевым замкнутым строением, приводят к др. изменениям структуры и физ. свойств молекул ДНК. Исследование влияния топологич. эффектов на строение и свойства ДНК и её биол. ф-ции, на регуляцию генетич. процессов является одной из задач молекулярной биологии.

Лит.: А. К. Ерман Ю., Биофизика, пер. с англ., М., 1964; Физические методы исследования белков и нуклеиновых кислот, М., 1967; Велезов А. А., Дыхие А. М., Франк-Каменецкий М. Д., Переход спираль — клубок в ДНК, «УФН», 1971, т. 105, в. 3, с. 479; В. Я. Мельников Л. А., Проблемы биологической физики, 2 изд., М., 1977; Шабарова З. А., Богданов А. А., Химия нуклеиновых кислот и их компонентов, М., 1978; Давуркин Ю. С., Молекулярное плавление ДНК и эффект тонких структурных изменений в «Молекулярная физика», 1977, т. 11, в. 8, с. 1311; Волынский И. М., Биофизика, 2 изд., М., 1988; Франк-Каменецкий М. Д., Вологодский А. В., Топологические аспекты физики полимеров: теория и её биологические приложения, «УФН», 1981, т. 134, в. 4, с. 641; Никитро Ч., Шиммель П., Биофизическая химия, пер. с англ., т. 1—3, М., 1984—85; «В мире науки», 1985, в. 12 (тематич. вып.); Молекулярная биология клетки, пер. с англ., т. 1—3, М., 1986—87; Вольгоцкий В. А., В., Топология и физические свойства кольцевых ДНК, М., 1988. Ю. С. Лазуркин.

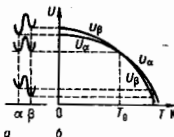
ПОЛИМОРФИЗМ (от греч. polymorphos — многообразный), способность нек-рых веществ существовать в состояниях с разл. атомно-кристаллич. структурой (см. Кристаллография). Каждое из таких состояний (термодинамич. фаз), называемое полиморфной модификацией, устойчиво при опред. внеш. условиях (темп-ре и давлении). Различие в структуре обуславливает различие в свойствах полиморфных модификаций данного вещества. П. открыт в 1822 нем. учёным Э. Мичерлихом (E. Mitscherlich). Им обладают нек-рые простые вещества (аллотропия) и мн. хим. соединения. Так, две модификации углерода — кубическая (алмаз) и гексагональная (графит) — резко различаются по физ. свойствам. Белое олово, имеющее

тетрагональную объёмноцентрир. кристаллич. решётку, — пластичный металл, а серое олово (низкотемпературная модификация) с алмазоподобной тетрагональной решёткой — хрупкий полупроводник. Некоторые вещества, напр. сера, кремнезём, вода, имеют больше чем две полиморфные модификации. II. наблюдается и у жидких кристаллов.

Области устойчивости полиморфных модификаций и точки перехода между ними определяются фазовыми диаграммами равновесия, расчёт к-рых основан на вычислении термодинамич. характеристик, а также спектра колебаний кристаллической решётки для разл. модификаций.

Структура кристаллич. решётки при $T = 0$ К определяется минимумом внутр. энергии \mathcal{E} системы частей. При $T > 0$ К структура определяется минимумом свободной энергии U , куда, кроме \mathcal{E} , входит энтропийный член TS , связанный с тепловыми колебаниями атомов: $U = \mathcal{E} - TS$, где S — энтропия. Для устойчивой низкотемпературной α -фазы зависимость $U(T)$ имеет вид, показанный на рис. Любой др. способ улавливания тех же атомов в кристалле (β -фаза) имеет при $T = 0$ $KU_{\beta} < U_{\alpha}$. Это означает, что β -фаза неустойчи-

Изменение свободной энергии U кристалла при изменении взаимного расположения виа атомов. Минимумы U соответствуют двум кристаллическим модификациям α и β (а); зависимость U от температуры (б).



ва при низких темп-рах. Однако из-за иного характера тепловых колебаний атомов кривая $U(T)$ идёт более полого, в точке T_0 она пересекается с кривой U_{β} , а далее идёт ниже. Это означает, что при $T < T_0$ устойчива α -фаза, при $T > T_0$ устойчива β -фаза, и точка T_0 является точкой равновесия фаз.

Фазовый переход 1-го рода менее стабильной модификации в более стабильную связан с преодолением энергетич. барьера, к-рый существенно меньше, если превращение происходит постепенно, путём зародышания и последоват. роста в ней областей новой фазы. Барьер преодолевается за счёт тепловых флуктуаций; поэтому, если вероятность флуктуаций мала, менее устойчивая фаза может длит. время существовать в метастабильном состоянии. Напр., алмаз, области стабильности к-рого соответствуют $T > 1500$ К и давление $p = 10^8$ Па, тем не менее может существовать неограниченно долго при атм. давлении и комнатной темп-ре, не превращаясь в стабильный при этих условиях графит. В др. веществах, напр. в *светоэлектрокиналах* и *сегнетоэластиках*, наоборот, разл. модификация легко и обратимо переходят друг в друга при изменении темп-ры, давления и др. претерпевая при этом структурные m -фазы в n переходов фаз. свойства вещества обычно экстремальны.

Частный случай II. — о л д и т и к а м, к-рый наблюдается в некр-рых кристаллах со сложной структурой (глинистые минералы кремния, карбид кремния и др.). Полигишые модификация построены из одинаковых слоёв или слоистых «пакетов» атомов и различаются способом и периодичностью наложения таких пакетов.

Полиморфные превращения могут сопровождаться изменением характера хим. связи и свойств. Напр., при высоких давлениях в некр-рых полупроводниках (Ge, Si) перекрыты и перестроены внеш. электронные оболочки атомов приводит к металлч. модификация. При давлении $2 \cdot 10^{11}$ Па возможно возникновение *металлического водорода*, при $5 \cdot 10^{10}$ Па — металлч. Al, Xe.

Лит.: Крамер А., Крайня П. П., Полиморфизм и подлинный и кристаллич. пер. с англ., М., 1980; Крайня П. Д., Теория превращений в металлах и сплавах, пер. с англ., ч. 1, М., 1978; Умывский Я. С., Скаков Ю. А., Физика металлов, М., 1978. А. Л. Ройтштерд. ПОЛИНОМИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (от греч. poly — многочисленный и лат. locus — имя) (мультиномиальное распределение) — совместное распределение k случайных величин ξ_i , принимающих целые

неотрицательные значения r_i , $i = 1, \dots, k$, $\sum_{i=1}^k r_i = N$:

$$P(\xi_1 = r_1, \dots, \xi_k = r_k) = \frac{N!}{r_1! \dots r_k!} p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k},$$

где $N \geq k$, $p_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. Ср. значения $M(\xi_i) = N p_i$, дисперсия

$$D(\xi_i) = N p_i (1 - p_i), \quad (1)$$

смешанные вторые моменты

$$D(\xi_i, \xi_j) = -N p_i p_j, \quad i \neq j, \quad (2)$$

производящая ф-ция

$$G(z_1, \dots, z_k) = (p_1 + p_2 z_2 + \dots + p_k z_k)^N.$$

II. р. является обобщением *биномиального распределения* на случай более двух возможных исходов эксперимента. Оно определяет вероятность при N независимых испытаниях получить r_i результатов типа i , если p_i — вероятность i -го исхода в одном испытании.

Характерным примером II. р. является распределение чисел событий в k ячейках *гистограмм*. Т. к. полное число событий N в гистограмме фиксировано и $\sum_{i=1}^k r_i = N$, то ранг матрицы вторых моментов $D(\xi_i, \xi_j)$ равен $k - 1$. Когда гистограмма содержит много ячеек и $p_i \ll 1$, часто пользуются приближёнными выражениями для (1) и (2):

$$D(\xi_i, \xi_j) \approx N p_i, \quad D(\xi_i, \xi_j) \approx 0, \quad i \neq j.$$

Лит.: Крамер Г., Математические методы статистики, пер. с англ., 2 изд., М., 1975; Статистические методы в экспериментальной физике, пер. с англ., М., 1976. В. П. Жуков.

ПОЛИТРОПА (от греч. poly — многочисленный и tropos — поворот, направление) — линия на термодинамич. диаграмме состояний, изображающая обратимый *политропный процесс*.

ПОЛИТРОПНЫЙ ПРОЦЕСС (политропический процесс) — обратимый термодинамич. процесс при пост. теплоёмкости системы. Линия, изображающая II. п. на термодинамич. диаграмме, наз. политропой. При II. п. кол-во подводимого тепла dQ пропорционально вызываемому тем самым повышению темп-ры dT , следовательно, $dQ = C dT$, где C — теплоёмкость при II. п. Для идеального газа внутр. энергия U пропорциональна темп-ре $C = C_V T$, так что, согласно *первому началу термодинамики*, $C = C_V + P(\partial V/\partial T)_C$, где P — давление, V — объём, C_V — теплоёмкость при пост. объёме. Интегрируя полученное уравнение с учётом уравнения состояния, находим уравнение для политропы идеального газа: $P V^m = \text{const}$ или $T V^{m-1} = \text{const}$, где $m = (C_P - C_V)/(C_V - C)$, C_P — теплоёмкость при пост. давлении. Изменение энтропии при II. п. равно $S_2 - S_1 = C \ln(T_2/T_1)$, т. к. $C = T(\partial S/\partial T)_C$.

Частные случаи II. п.: *адиабатический процесс*, $C = 0$, $m = \gamma > 1$, где $\gamma = C_P/C_V$ — коэф. Пуассона; *изотермический процесс*, $m = 1$, $C = \infty$; *изобарный процесс*, $m = \infty$, $C = C_P$; *изобарный процесс*, $m = 0$, $C = C_P$.

Для неидеальных газов показател m можно приближённо считать постоянным лишь в некр-ром интервале термодинамич. параметров, поэтому II. п. в техн. термодинамике лишь приближённо представляет реальные термодинамич. процессы.

Лит.: Жуковский В. С., Термодинамика, М., 1983; Новиков И. И., Термодинамика, М., 1984. Д. Н. Зубарев.

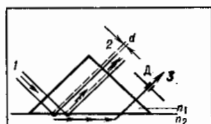
ПОЛНАЯ СИСТЕМА ФУНКЦИЙ — см. в ст. *Ортогональная система функций*.

ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ — отражение эл.-магн. излучения (в частности, света) при его падении на границу двух прозрачных сред с показателем преломления n_1 и n_2 из среды с большим показателем преломления ($n_1 > n_2$) под углом $\varphi \geq \varphi_{\text{Фр}}$ для к-рого $\sin \varphi_{\text{Фр}} = n_2/n_1 = n_{21}$. Наим. угол падения $\varphi_{\text{Фр}}$ при к-ром происходит П. в. о., наз. предельным (критическим) углом полного отражения. Впервые П. в. о. описано И. Кеплером (J. Kepler) в 1600. Поток излучения, падающий при углах $\varphi \geq \varphi_{\text{Фр}}$, испытывает полное отражение от грани раздела, целиком возвращается в среду с n_1 , т. е. коэф. отражения $R = 1$. В оптически менее плотной среде n_2 в области vicinity границы существует конечное значение эл.-магн. поля, однако поток энергии через границу отсутствует, т. к. перпендикулярная компонента *Пойнтинга вектора*, усреднённая во времени, равна нулю. Это означает, что энергия проходит через границу дважды (входит и выходит обратно) и распространяется лишь вдоль поверхности среды в плоскости падения. Глубина проникновения излучения в среду n_2 определяется как расстояние, на к-ром амплитуда эл.-магн. поля в оптически менее плотной среде убывает в e раз. Эта глубина зависит от относит. показателя преломления n_{21} , длины волны λ и угла φ . Вблизи $\varphi_{\text{Фр}}$ глубина проникновения наибольшая, с ростом угла вплоть до 90° плавно сходает до пост. значения.

Поле эл.-магн. излучения в среде n_2 существенно отличается от поля проходящей поперечной волны, т. к. в среде n_2 компонента амплитуды электрич. вектора в направлении распространения волны не равна нулю. Все три компоненты x , y , z амплитуды волны имеют конечные значения при всех углах $\varphi > \varphi_{\text{Фр}}$ и в области $\varphi_{\text{Фр}}$ могут значительно превышать по величине нач. значение амплитуды падающей волны (см. *Нарушенное полное внутреннее отражение*).

Процесс распространения эл.-магн. излучения при П. в. о. в случае ограниченных пучков сопровождается

Схема распространения латеральной волны при полном внутреннем отражении вблизи критического угла пучка света с конечным поперечным сечением: 1 — падающий пучок; 2 — геометрически отражённый пучок; 3 — латеральная волна; 4 — диафрагма.



продольным и поперечным смещением падающего пучка. Величина продольного смещения d зависит от состояния поляризации пучка, угла падения φ , величины n_{21} и вблизи $\varphi \approx \varphi_{\text{Фр}}$ равна

$$d_{p,s} = K_{p,s} \frac{n_{21}}{\pi n_1} \frac{\lambda}{(\sin^2 \varphi - n_{21}^2)^{1/2}}.$$

Для излучения, поляризованного в плоскости падения (p -поляризация), $K_p = 1/n_1^2$; для излучения, поляризованного перпендикулярно плоскости падения (s -поляризация), $K_s = 1$. Величина смещения пучка при П. в. о. коррелирует с глубиной проникновения эл.-магн. излучения в оптически менее плотную среду n_2 . Величина смещения сравнима с глубиной проникновения и по порядку величины близка λ .

При П. в. о. p - и s -компоненты поляризованного излучения испытывают различный по величине сдвиг фаз, поэтому линейно поляризованное излучение после отражения становится эллиптически поляризованным. Разность фаз p - и s -компонент определяется из выражения

$$\lg \frac{\delta}{2} = \frac{\cos \varphi (\sin^2 \varphi - n_{21}^2)^{1/2}}{\sin^2 \varphi}.$$

Величина δ имеет минимум в области углов $\varphi_{\text{Фр}} \approx 90^\circ$. Подбирая подходящий угол падения и значение n_{21} , можно получить сдвиг фаз, равный $\pi/4$; для двух отражений величина сдвига удваивается. Такой приём используется в поляризах. устройствах (призма — ромб Френеля, см. *Поляризационные приборы*) для преобразования линейно поляризованного излучения в круговое.

Вследствие дифракции, обусловленной конечными размерами падающего пучка, при П. в. о. вряду с рассмотренным продольным смещением пучка наблюдается латеральная (поперечная) волна, распространяющаяся вдоль поверхности, к-рая играет роль своеобразного волновода (рис.). Латеральная волна возникает при угле, превышающем $\varphi_{\text{Фр}}$ всего на $\sim 1'$, и распространяется на расстояние, на неск. порядков превышающее величину продольного смещения регулярной волны, имеющей интенсивность, близкую к единице. Интенсивности I_p и I_s пучков отражённой латеральной волны для p - и s -поляризованного излучения уменьшаются вдоль поверхности пропорционально кубу расстояния, на к-рое произошло смещение волны, и относятся между собой как $1/2 I_p \propto (n_2/n_1)^4$. В опыте с гелиево-лазерным лучом для границы вода — воздух латеральная волна регистрировалась на расстоянии до 7 см. Для расстояния 3 см и $\lambda = 441,8$ нм интенсивность волны составляла $1,6 \cdot 10^{-4}$ от мощности падающего пучка света.

В отличие от селективного отражения металлов, к-рое может быть весьма высоким (но всегда коэф. отражения $R < 1$), при П. в. о. для прозрачных сред $R = 1$ для всех λ и не зависит практически от числа отражений. Следует, однако, отметить, что отражение от механически полированной поверхности из-за рассеяния в поверхностном слое чуть меньше единицы на величину $\sim 2 \cdot 10^{-4}$. Потери на рассеяние при П. в. о. от более совершенных границ раздела, напр. в волоконных световодах, ещё на неск. порядков меньше. Высокая отражат. способность границы в условиях П. в. о. широко используется в *интерфальной оптике*, оптич. линиях связи, *световодах* и оптич. призмах. Высокая крутизна коэф. отражения вблизи $\varphi_{\text{Фр}}$ лежит в основе размерит. устройств, предназначенных для определения показателя преломления (см. *Рефрактометр*). Особенности конфигурации эл.-магн. поля в условиях П. в. о., а также свойства латеральной волны используются в физике твёрдого тела для исследования поверхностных возбуждённых колебаний (плазмонов, поляритонов), находят широкое применение в спектроскопич. методах контроля поверхности на основе нарушенного П. в. о., *комбинационного рассеяния света*, *люминесценции* и др. для обнаружения весьма низких значений концентраций молекул и величин поглощения, вплоть до значений безразмерного показателя поглощения $k \geq 10^{-4}$.

Лит.: В р е т о в с к и й Л. М., Волны в слоистых средах, 2 изд., М., 1973; К и з е л ь В. А., Отражение света, М., 1973; К а л ы т е е в с к и й Н. И., Волноводная оптика, 2 изд., М., 1978.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ — атомы или молекулы газа, лишенные в результате взаимодействия одного или неск. электронов с внеш. оболочкой. Вместе с комплексом др. атомов или молекул П. и. могут образовывать *катионные ионы*. Подробнее см. *Ион, Ионизация*.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛЫ — одноосные кристаллы, в к-рых скорость распространения обыкновенного луча больше, чем скорость распространения необыкновенного луча (подробнее см. *Кристаллооптика*).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБ — часть столба люевого разряда между анодом и отрицательными пространственными. В области П. с. электропроводность максимальна, а напряженность элетрич. поля минимальна; объемный заряд отсутствует. Ионизация (прямая или ступенчатая) осуществляется электрощным ударом, а уход заряд. частиц (в радиальном направлении) — в осн. амбипольной диффузией. При значениях параметра pd (p — давление газа, d — диам. разрядной трубки), меньших нек-рого критического, скорость ионизации резко падает, а уход заряд. частиц возрастает настолько, что поддержание существования П. с. становится невозможным. Критич. значение pd сильно зависит от рода газа; так, в гелии оно $\sim 10^8$ торр·см, в парах ртути $\sim 10^4$ торр·см. В П. с. при низких давлениях, когда длина свободного пробега понов $\lambda > d$, осуществляется режим «свободного падения» ионов на стенку. Теория П. с. для такого режима создана И. Ленгмюром (I. Langmuir) и Л. Тонксом (L. Tonks). При давлениях $\sim 10^{-1} \div 10$ торр и $\lambda \ll d$ осуществляется диффузионный режим. Теория П. с. для таких условий создана В. Шоттки (W. Schottky). При дальнейшем повышении p всё большую роль начинают играть объёмные потери заряд. частиц в разл. процессах рекомбинации. С повышением p или тока наблюдается также *контракция анодного разряда*. В П. с. в широком диапазоне условий может возникать иониз. неустойчивость, проявляющаяся в виде *страт.*

Лит. см. при ст. Тлеющий разряд. В. Н. Колесников.
ПОЛОНИЙ (Polonium), Po, — хим. элемент VI группы периодич. системы элементов, ат. номер 84; первый хим. элемент, открытый по его радиоакт. свойствам (1898, П. и М. Кюри, Р. и М. Сюри). Известны изотопы ^{210}Po — ^{218}Po . Наиб. устойчив ^{210}Po ($T_{1/2} = 102$ года), однако его получение в чистом виде сложно, поэтому для практич. целей применяют ^{210}Po (α -радиоактивен, $T_{1/2} = 138,39$ сут., κ -ий является членом естеств. радиоакт. ряда ^{238}U . Конфигурация веш. электронных оболочек $6s^2 4f^4$. Энергии последоват. ионизации 8,2; 19,4; 27,3; 38; 57,1; 73 эВ соответственно. Металлич. радиус атома Po 0,153 нм, радиус иона Po^{4+} 0,065 нм, Po^{4+} 0,056 нм. Значение электроотрицательности 2,0.

В свободном виде серебристо-белый металл, существует в двух модификациях: α -Po (кубич. кристаллич. структура, постоянная решетки $a = 0,3359$ нм) и β -Po (ромбоэдрич. кристаллич. структура с постоянной $a = 0,3368$ нм и углом $\alpha = 98,08^\circ$); темп-ра перехода $\alpha \leftrightarrow \beta$ 36°C (по др. данным, 54°C), при $18-54^\circ\text{C}$ обе модификации сосуществуют друг с другом. Плотность α -Po 9,20 кг/дм³, β -Po — 9,40 кг/дм³, $t_{\text{пл}} = 246-254^\circ\text{C}$ (по разл. данным), $t_{\text{кип}} = 962^\circ\text{C}$, теплоёмкость $c_p = 24,6$ Дж/моль·К, теплол. плавления 12,5 кДж/моль. Уд. элетрич. сопротивление 0,42—0,44 мОм·м (при 0°C), термич. коэф. линейного расширения $20,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (при $180-303 \text{ K}$).

В соединениях проявляет степени окисления $-2, +2, +4, +6$. С водородом образует летучее соединение. Металлич. П. и его соединения сильно токсичны. ^{210}Po применяют в ампульных источниках нейтронов, а также как источник энергии в атомных батареях.

С. С. Берлинский.

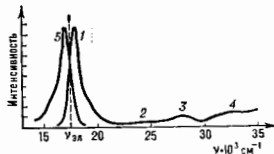
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ — область частот, в κ -рой колебания, проходящие через радиотехн., акустич., оптич. и др. устройства, изменяют свою амплитуду и др. параметры в установленных границах. Для элетрич. цепей в пределах П. п. сопротивление цепи (в зависимости от её типа) близко к своему макс. или мин. значению (напр., параллельно или последовательно включённый колебат. контур). П. п. — важная характеристика резонансных систем, фильтров и др. В радиотехнике принято оценивать ширину П. п. по определ. уровню (обычно $1/\sqrt{2}$) амплитудно-частотной характеристики цепи относительно её макс. значения. П. п.

одиночного контура зависит от потери энергии в контуре, а в системе контуров (фильтре) определяется степенью связи (обменом энергии) между отд. контурами системы.

С. Ф. Лутман.

ПОЛОСАТЫЕ СПЕКТРЫ — оптич. спектры молекул и кристаллов. Возникают при электронных переходах в молекулах или межзонных переходах в кристаллах. П. с. состоит из широких спектральных полос, положение κ -рых характерно для данного вещества. В спектрах простых молекул электронные полосы распадаются на более или менее узкие колебат. полосы и вращат. линии. Полосы сложных молекул чаще сплошные, лишены дискретной структуры (рис.). Полосы могут уши-

Спектры роданина С глицерине: 1 — длинноволновая иттенсивная полоса поглощения; 2—4 — полосы поглощения; 5 — полоса люминесценции; $\nu_{\text{вн}}$ — частота чисто адекватного поглощения.



ряться при разл. воздействиях на вещество (напр., доплеровское уширение при росте темп-ры). Исследования П. с. молекул и кристаллов позволяют получать информацию об их строении (см. Молекулярные спектры, Спектры кристаллов).

ПОЛОСКОВЫЕ ЛИНИИ — линии передачи, содержащие проводники в виде одной или неск. полосок, расположенных в воздухе (воздушные П. л., рис. 1, а, б) либо нанесённых на диэлектрик (рис. 1, в—д), наз. подложкой. Иногда в качестве подложки применяют феррит или полупроводник. Воздушные П. л. чаще используют в диапазоне частот 1—100 МГц, а П. л., нанесённые на диэлектрик, — до 100 ГГц. Наиб. распространены П. л., у κ -рых одна поверхность подложки полностью металлизирована (микроросконовые линии, рис. 1, е, з). Они обеспечивают простое соединение

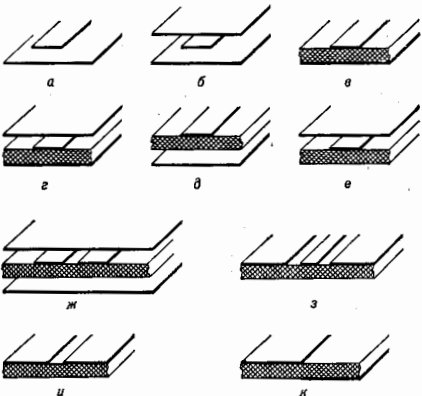


Рис. 1.

активных элементов *интегральными схем* (ИС) с подложкой через металлизиров. отверстия в ней; применяются вплоть до миллиметрового диапазона волн. В миллиметровом диапазоне чаще используются подвесные (рис. 1, б, ж) и обращённые (рис. 1, е) линии.

Электрич. свойства П. л. характеризуются волновым сопротивлением Z_0 , коэф. замедления n (см. *Замедляющая система*) и коэф. затухания α . Подвешенные и обрамленные П. л. отличаются от др. П. л. тем, что сторона подложки, противоположная полоскам, не металлизирована; они обладают меньшими потерями энергии в проводниках, чем микрополосковые линии, допускают передачу большей мощности. Волновые сопротивления и коэф. замедления этих линий зависят от расстояний между диэлектриком и экранами, что используют для перестройки устройств на П. л. и для выравнивания скоростей чётных и нечётных волн в связанных линиях (рис. 1, ж). Такое выравнивание необходимо для создания широкополосных направленных ответвителей.

К П. л. относятся копланарная (рис. 1, а) и щелевые (рис. 1, и) линии. Все проводящие полоски этих линий расположены с одной стороны подложки. Поэтому они допускают монтаж активных элементов, в т. ч. соединение с элементной базой, с одной стороны подложки и удобны для создания монолитных ИС. В сочетании с П. л., нанесёнными на др. сторону подложки, они существенно расширяют возможности создания разл. конструкций ИС.

В П. л. могут существовать разл. типы волн, отличающиеся распределением поля и тока по ширине полоски. Их дисперсионные характеристики (сплошные линии) представлены на рис. 2. Осн. тип волны (кривая 0) наз. квази-ТЕМ-волной, поскольку эта волна, как и ТЕМ-волна, может распространяться в диапазоне длин волн $0 < \lambda < \infty$, поперечные компоненты эл.-магн. поля в ней существенно больше, чем продольные (в ТЕМ-волне продольные компоненты поля отсутствуют; см. *Волновой металлический*), а при достаточном больших длинах волн ($\lambda > 16h\sqrt{\epsilon_r}$ и $\lambda > 8W\sqrt{\epsilon_r}$) она описывается *телеграфными уравнениями*. Здесь ϵ и μ — относительные электрич. и магн. проницаемости материала подложки, W — ширина полоски, h — толщина подложки. По мере уменьшения λ (роста частоты) коэф. замедления всех типов волн стремится к величине $\sqrt{\epsilon_r}$, соответствующей волне, к-рая распространяется в среде, имеющей те же параметры, что и подложка П. л. Рост замедления связан с тем, что по мере увеличения частоты ал.-магн. поле сосредоточивается в диэлектрике. Наб. быстрый рост замедления квази-ТЕМ-волны происходит вблизи частот, при к-рых в подложке укладываются четверть волны ($\lambda = 4h\sqrt{\epsilon_r}$), а на ширине полоски — половина ($\lambda = 2W\sqrt{\epsilon_r}$). Квази-ТЕМ-волна полностью определяется погонными вдуктивностью L , ёмкостью C , сопротивлением проводника

R , проводимостью подложки G . Через эти параметры определяются такие величины, как коэф. замедления $n = c\sqrt{LC}$ (здесь c — скорость света в свободном пространстве), волновое сопротивление $Z_0 = \sqrt{L/C}$, затухание $\alpha = 4,34(R/Z_0 + Z_0/G)$. Часто при $\mu = 1$ в области частот, для к-рой справедливы телеграфные уравн., вместо коэф. замедления используют эфф. диэлектрич. проницаемость $\epsilon_{эф} = n^2$, поскольку в этой области $n^2 = c^2/C_1^2$, где C_1 — погонная ёмкость П. л. в отсутствие подложки. Дисперсионные характеристики $n(W/\lambda)$ высших типов волн в П. л. близки к дисперсионным характеристикам волн в диэлектрич. волноводе. Эти типы волн используются для создания на основе П. л. высокооборотных резонаторов. Поле в П. л. локализовано вблизи проводящей полоски, если коэф. замедления волн в П. л. (рис. 2, кривые 0, 1, 2) выше, чем в двухслойном волноводе (рис. 2, кривая 3). В противном случае возможно излучение волны колоской, т. е. трансформации волны в П. л. в волну двойной волновода. Излучение возможно также на неоднородностях в П. л. (повороты, разрывы, навесные элементы и т. п.). Область значений n , лежащая выше кривой 3, на область спектра дискретного спектра, а ниже — область непрерывного спектра, поскольку в последнем случае коэф. замедления и длины волн (частоты) могут принимать любые значения.

П. л. отличаются от др. линий передачи малыми габаритами и простой изготовлением; допускают применение планарной технологии (нанесение, фотолитография и т. п.), поэтому удобны для создания ИС как в качестве линий передачи эл.-магн. энергии, так и в качестве элементов СВЧ-устройств (резонаторов, фильтров, линий задержки, направленных ответвителей и др.).

Лит.: Нефедов Е. И., Фвазковский А. Т., Полосковые линии передачи, 2 изд., М., 1980; Справочник по расчёту и конструированию СВЧ полосковых устройств, под ред. В. И. Волынова, М., 1982; Гупта К., Гарднер Р., Чатхав Р., Машинное проектирование СВЧ-устройств, пер. с англ., М., 1987. Р. А. Сильин.

ПОЛОСТЬ РОША — пространственная область, определяющая макс. размеры стационарной вращающейся звезды (одиночной или в двойной системе). Границей П. Р. является т. н. критич. эквипотенциальная поверхность, на к-рой эфф. сила притяжения (см. ниже) обращается в нуль (хотя бы в одной точке). П. Р. названа по имени Э. А. Роша (E. A. Roche), исследовавшего фигуры равновесия тел вращения (1849—51). Большое значение понятие П. Р. приобрело во 2-й пол. 20 в. в связи с задачами экваториального истечения из быстровращающихся одиночных звёзд, а также переноса вещества с одной компоненты на другую в *тесных двойных звёздах* на поздних стадиях их эволюции.

Поверхность стационарной вращающейся звезды совпадает с нек-рой эквипотенциальной поверхностью. Эфф. потенциал Φ на поверхности одиночной вращающейся звезды определяется суммой гравитат. Φ_g и центробежного Φ_c потенциалов. Вращение нарушает сферически-симметричное распределение массы в звезде. Однако для большинства обычных звёзд из-за сильной концентрации вещества к центру обусловленные вращением отличия гравитат. потенциала от сферически-симметричного малы. Поэтому Φ_g на поверхности таких звёзд мало отличается от потенциала точечной массы: $\Phi_g = -GM/R$ (M — масса звезды, R — расстояние от центра звезды). При вращении о нек-рой угл. скоростью ω (не зависящей от координат) центробежный потенциал $\Phi_c = -(\omega^2/2)R^2 \sin^2\theta$ (θ — полярный угол). Т. о., форма стационарной вращающейся звезды (рис. 1) определяется одной из эквипотенциальных поверхностей

$$\Phi(R, \theta) = \frac{GM}{R} - \frac{1}{2}\omega^2 R^2 \sin^2\theta = C.$$

На экваторе критич. эквипотенциальной поверхности ($\theta = 90^\circ$, $R = R_c$) сила притяжения на единицу массы,

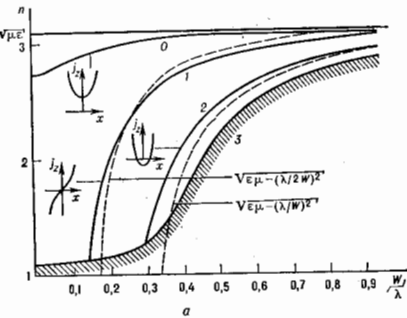
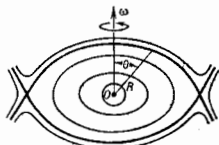


Рис. 2.

вая 0) наз. квази-ТЕМ-волной, поскольку эта волна, как и ТЕМ-волна, может распространяться в диапазоне длин волн $0 < \lambda < \infty$, поперечные компоненты эл.-магн. поля в ней существенно больше, чем продольные (в ТЕМ-волне продольные компоненты поля отсутствуют; см. *Волновой металлический*), а при достаточном больших длинах волн ($\lambda > 16h\sqrt{\epsilon_r}$ и $\lambda > 8W\sqrt{\epsilon_r}$) она описывается *телеграфными уравнениями*. Здесь ϵ и μ — относительные электрич. и магн. проницаемости материала подложки, W — ширина полоски, h — толщина подложки. По мере уменьшения λ (роста частоты) коэф. замедления всех типов волн стремится к величине $\sqrt{\epsilon_r}$, соответствующей волне, к-рая распространяется в среде, имеющей те же параметры, что и подложка П. л. Рост замедления связан с тем, что по мере увеличения частоты ал.-магн. поле сосредоточивается в диэлектрике. Наб. быстрый рост замедления квази-ТЕМ-волны происходит вблизи частот, при к-рых в подложке укладываются четверть волны ($\lambda = 4h\sqrt{\epsilon_r}$), а на ширине полоски — половина ($\lambda = 2W\sqrt{\epsilon_r}$). Квази-ТЕМ-волна полностью определяется погонными вдуктивностью L , ёмкостью C , сопротивлением проводника

рис. 1. Вид сечений эквипотенциальных поверхностей вращающейся одиночной вращающейся звезды плоскостью, проходящей через ось вращения. Критическая эквипотенциальная выделена полужирной линией, O — центр масс звезды.



равная $-GM/R_0^2$, уравновешена центробежной силой $R_0^2 \omega^2$ (т. е. эфф. сила притяжения $F = -\nabla\Phi = 0$), и постоянная $C = -(3/2)GM/R_0$. На полюсе ($\theta = 0$, $R = R_0$), где центробежная сила отсутствует, $GM/R_0 = -(3/2)GM/R_0$. Максимально возможное отношение экваториального R_0^* и полярного R_p^* радиусов звезды, заполняющей П. Р., $R_0^*/R_p^* = 3/2$. С уменьшением размеров звезды (относительно П. Р.) $R_0^*/R_p^* \rightarrow 1$. Угл. скорость вращения стационарной звезды не может превышать величины $\omega_n = (GM/R_0^*)^{1/2}$, иначе у неё начнётся экваториальное истечение вещества. Однако не все звёзды могут быть ускорены к-л. из известных механизмов до $\omega = \omega_n$. Так, в рамках моделей нейтронных звезд со слабой концентрацией массы к центру (с «жестким» ур-нем состояния) устойчивость звезды нарушается при $\omega < \omega_n$.

Появие эквипотенциальных поверхностей и П. Р. можно ввести также и для системы двух звезд, обращающихся вокруг общего центра тяжести по круговым орбитам с пост. угл. скоростью ω . В неинерциальной системе координат, вращающейся с той же угл. скоростью, эфф. потенциал стационарен и определяется суммой гравитацион. потенциалов обеих компонент и центрального потенциала:

$$\Phi(R, \theta, \varphi) = -\frac{GM_1}{R_1(R, \theta, \varphi)} - \frac{GM_2}{R_2(R, \theta, \varphi)} - \frac{1}{2} \omega^2 R^2 \sin^2 \theta,$$

где R_1, R_2 и M_1, M_2 — расстояния от центров и массы звезд R, θ, φ — сферич. координаты (центр системы — в центре масс, ось $\theta = 0$ параллельна ω), предполагается синхронность вращения (угл. скорость вращения звезд равна ω).

Эквипотенциальные поверхности, $\Phi = C$, при больших значениях модуля C ($C = C_1$) состоят из окружающих каждую массу почти концентрич. сфер и одной внеш. поверхности, по форме близкой к круговому цилиндру (рис. 2). С уменьшением $|C|$ размеры экви-

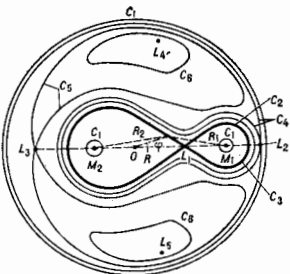


рис. 2. Вид сечений эквипотенциальных поверхностей в двойной системе звезды плоскостью, проходящей через центры масс компонент и ортогональной оси вращения системы. Критическая эквипотенциальная выделена полужирной линией, φ — азимутальный угол, O — центр масс системы. Внешние эквипотенциалы, соответствующие $C = C_2, C_3$, не показаны.

потенциальных поверхностей возрастают, они деформируются, превращаясь в вытянутые навстречу друг другу фигуры, и при нек-ром значении $C = C_0$ имеют место пересечение этих фигур. Точка пересечения (L_1) назв. внутр. либрац. точкой Лагранжа. Эквипотенци-

альная поверхность, проходящая через L_1 , назв. критической и определяет П. Р. каждой из компонент двойной системы. Поверхности звезд должны совпадать с одной из внутр. эквипотенциалей. При выполнении одной из компонент своей П. Р. начнется интенсивное перетекание вещества на соседнюю компоненту.

В зависимости от соотношения между размерами компонент и П. Р. существует классификация двойных звездных систем: разделенные системы, у к-рых обе компоненты находятся внутри П. Р.; полуразделенные системы, у к-рых одна из компонент заполняет свою П. Р.; контактные системы — обе компоненты заполняют свои П. Р. В процессе эволюции звезд одна и та же двойная система может переходить из одного класса в другой.

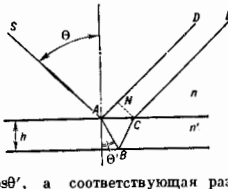
В полуразделенных и контактных системах наблюдаются газовые потоки, движение к-рых определяется структурой эквипотенциальных поверхностей вне П. Р. С дальнейшим уменьшением $|C|$ ($C = C_2$) две внутр. эквипотенциальные поверхности за П. Р. сливаются в одну гантелеподобную фигуру и при нек-ром значении $C = C_1$ наступает пересечение этой фигуры с внеш. эквипотенциальной поверхностью в либрац. точке L_2 , к-рая находится за менее массивной компонентой на линии, соединяющей центры масс звезд. Если вещество газовых потоков обладает достаточной кинетич. энергией, то прежде всего она начнет уходить из системы через окрестности L_2 .

При ещё меньших значениях $|C|$ ($C = C_3$) наступает пересечение эквипотенциальных поверхностей с внеш. стороны более массивной компоненты в точке L_3 , после чего эквипотенциальные поверхности разделяются на две фигуры ($C = C_0$), расположенные «выше» и «ниже» линии, соединяющей центры масс. Наконец, при нек-ром значении C эти фигуры вырождаются в две точки L_4 и L_5 , носители назв. треугольных либрац. точек Лагранжа. При любом отношении масс компонент эти точки образуют с центрами масс звезд равнобедренные треугольники $L_4M_1M_2$ и $L_5M_1M_2$. Положение точек L_1, L_2, L_3 на линии, соединяющей центры компонент, зависит от отношения масс. Все либрац. точки являются точками относ. равновесия, т. е. в них $\nabla\Phi = 0$. L_1, L_4, L_5 — точки неустойчивого равновесия. В линейном приближении равновесие в точках L_4, L_5 устойчиво при условии $27M_1M_2 < (M_1 + M_2)^2$.

В системе двух звезд, обращающихся друг относительно друга по эллиптич. орбитам, гравитац. поле попеременно и стационарные эквипотенциальные поверхности отсутствуют. Макс. размеры звезд здесь ограничены началом истечения вещества под действием переменных приливных сил в момент прохождения периастра.

Лит.: Мультион Ф. Введение в небесную механику. пер. с англ., М.—Л., 1936; Мэртти и о в Д. Я. Курс общей астрофизики, 3 изд., М., 1979.

ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА — чередующиеся тёмные и светлые полосы (интерференционные полосы), возникающие при падении света на плоскостранную пластину в результате интерференции лучей, отражённых от верхней и нижней её поверхностей и выходящих параллельно друг другу. Монохроматич. свет с длиной волны λ от точечного источника S (рис.), находящегося в среде с показателем преломления n , падает на пластину толщиной h и с показателем преломления n' ; при отражении луча SA от верхней и нижней грани образуются параллельные луча AD и CE . Оптич. разность хода между такими лучами $\Delta L = n'(AB + BC) - nAN = 2n'h \cos \theta'$, а соответствующая разность фаз $\delta = (2\pi/\lambda)n'h \cos \theta'$. С учётом сдвига фаз на



я при отражении $\delta = (4\pi h/\lambda) \sqrt{n^2 - n^2 \sin^2 \theta} + \pi$, т. е. при постоянстве h и λ разность фаз δ определяется наклоном лучей относительно пластины: при равном наклоне и разность фаз постоянна. Чтобы лучи AD и CE интерферировали, необходимо их совмещение, что достигается для параллельных лучей в бесконечности. Наблюдается они при аккомодации глаз на бесконечность или с помощью линзы, в фокусе к-рой помещают экран. Разность фаз δ не связана с положением источника света: лучи, испущенные соседней точкой источника и отражённые под тем же углом θ , будут иметь ту же разность фаз, а при просеивании на экран попадут в ту же точку. Поэтому при использовании протяжённого источника полосы оказываются столь же отличимыми, как и с точечным источником. Если оптич. ось пучка света нормальна к пластинке ($\theta = 0$), то П. р. и. приобретает вид концентрич. колец, что используется в частности в *интерферометре Фабри — Перо*, полосы на выходе к-рого — пример П. р. и. Благодаря большому отношению $n^2 h/\lambda$ у интерферометра Фабри — Перо небольшие изменения λ ведут к большому изменению δ , что позволяет использовать интерферометр Фабри — Перо как спектральный прибор высокой разрешающей силы либо как частотный фильтр в *открытом резонаторе*.

Лит.: Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Сивухин Д. В., Общий курс физики, 2 изд., [т. 4] — Оптика, М., 1985.

А. П. Газарин.

ПОЛОСЫ РАВНОЙ ТОЛЩИНЫ — интерференц. полосы, наблюдаемые при освещении тонких оптических прозрачных слоёв (плёнок) переменной толщины пучком параллельных лучей и обрисовывающие линии равной *оптической толщины*. П. р. т. возникает, когда интерференц. картина локализована на самой плёнке. Разность хода между параллельными монохроматич. лучами, отражёнными от верхней и нижней поверхностей плёнки (рис.), равна $\Delta L = 2nh \cos \theta$ (n — показатель преломления плёнки, h — её толщина, θ — угол преломления). Учитывая изменение фазы на π при отражении от одной из поверхностей плёнки, получим, что максимумы интенсивности (светлые полосы) возникают при разности хода $\Delta L' = 2nh \cos \theta \pm \lambda/2 = m\lambda$, $m = 0, 1, 2, \dots$ а минимумы (тёмные полосы) — при $\Delta L' = 2nh \cos \theta \pm \lambda/2 = (m + 1/2)\lambda$ (λ — длина волны света, в к-ром происходит наблюдение). Условие параллельности лучей выполняется, если расстояние от источника света до плёнки значительно больше $2h \sin^2 \theta$ — расстояния между точками пересечения интерферирующих лучей с поверхностью плёнки. При достаточно малом зрачке наблюд. прибора это условие выполняется и для протяжённого источника.

Если плёнка идеально одинаковой толщиной, то в любом её месте разность хода ΔL будет одна и та же, условия интерференции будут одинаковыми по всей плёнке, что приведёт к одинаковому по всей площади плёнки оптич. эффекту — ослаблению либо усилению света, а никакие интерференц. полосы не возникнут. На идеальной плоскoпараллельной пластине интерференц. полосы возникают при др. схеме наблюдения (см. *Полосы равного наклона*). Если же толщина плёнки немного меняется от точки к точке, то интерференц. полосы будут располагаться вдоль участков плёнки с одинаковыми разностями хода ΔL , т. е. с одинаковыми значениями толщины плёнки h (что и определило их назв.).

Примером регулярных П. р. т., образующихся в воздушном зворе между двумя сферич. поверхностями или сферой и плоскостью, являются *Ньютона кольца*.

При освещении белым светом разл. толщ. плен. h будут соответствовать разл. λ , для к-рых слой обла-

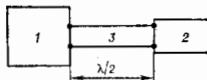
дает наиб. прозрачность и наим. отражат. способность. Это создает при малых h радужную окраску тонких плёнок (мыльных пузырей, масляных и бензиновых пятен).

П. р. т. используют для определения микрорельефа тонких пластинок и плёнок. П. р. т., возникающие в воздушном зворе между пробным стеклом и испытуемой поверхностью, характеризуют отклонение испытуемой поверхности от эталонной. Такие измерения обычно ведутся при наведении света на поверхность, близком к нормальному. При этом условии для тёмной полосы при $\cos \theta = 1$ преобразуется в $h = m\lambda/2$. Т. о., расстояние между соседними тёмными (или светлыми) полосами соответствует изменению толщины зраора на $\lambda/2$, т. е. при наблюдении в видимом свете $\sim 0,3$ мкм.

Лит.: Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973.

А. П. Газарин.

ПОЛУВОЛНОВАЯ ЛИНИЯ — отрезок *линии передачи (волновод)*, двухпроводной линии, коаксиального кабеля), длина к-рого равна целому числу волноволн в линии. Если нагрузка 1, частично поглощающая и отражающая падающую волну, подключена к к-л. устройству 2 через П. л. λ (рис.), то коэф. отражения



Полуволовая линия (λ — длина волны в линии).

(см. *Отражение радиоволн*) от входа П. л. $\rho_{\text{вх}}$ в случае пренебрежимо малых потерь в ней в точности равен коэф. отражения ρ , к-рый имела бы нагрузка 1, подключённая к устройству 2 непосредственно. П. л. как бы переносит без изменения свойства нагрузки на нек-рое расстояние. Эта особенность П. л. объясняется тем, что при распространении по ней от входа к выходу и обратно эл.-маг. волна приобретает доплнит. один фаз, равный $2\pi\lambda$, так что комплексные коэф. отражения от входа и от выхода оказываются одинаковыми. П. л. применяется как составной элемент разл. ВЧ- и СВЧ-устройств, антенн и др.

И. В. Иванов.

ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР (полуволовый диполь) — простейшая приёмная и передающая антенна, гл. обр. в области *коротких волн* и *ультракоротких волн*. Представляет собой проводящий стержень, длина к-рого близка к половине длины волны излучаемых или принимаемых колебаний. Для связи с генератором или приёмником в ср. части стержня делается разрыв, к к-рому подключается *фидер*. П. в. можно упрощённо рассматривать как четвертьволновый отрезок разомкнутой двухпроводной линии, проводники к-рой разделены на угол 180° (см. *Линии передачи*). При этом в идеальном П. в. (без потерь) ток распределён по длине по закону $I(z) = I_0 \cos z/l$, где l — длина П. в., а I_0 — ток в пучности (в месте подключения питающей линии). Эл.-магн. поле в ближней зоне П. в. распределено так, что преимуществ. излучение или приём имеет место в плоскости xy (перпендикулярной оси П. в. Oz и проходящей через его центр O). Линии электр. поля располагаются в плоскостях, пересекающихся по оси Oz , а линии магн. поля образуют окружности с центрами на оси Oz , лежащие в перпендикулярных плоскостях. *Диаграмма направленности* П. в. представляет собой поверхность тела вращения относительно Oz и описывается в любом аксиальном сечении выражением $G = \cos \theta$, где θ — угол между плоскостью преимуществ. излучения и лучом из центра П. в. *Сопротивление излучения* П. в. равно $\sim 73 \Omega$. Потери, связанные с проводимостью, в П. в. обычно пренебрежимо малы, так что согласованный с фидером П. в. излучает практически всю подводимую энергию,

и его кид весьма высок (более 90%). П. в. применяется обычно как активный доплер, образующий в разл. сочетаниях с системой пассивных доплеров млн. типов антенн с направленным излучением. И. В. Исмаев.

ПОЛУМАГНИТНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ (разбавленные магнитные полупроводники) — полупроводниковые тв. растворы, в к-рых осн. диамагн. кристаллич. решётка содержит нек-рое кол-во парамагн. примесных атомов. Концентрация последних не слишком велика, так что дырь-дырьное взаимодействие между их магн. моментами M мало. При этом расстояние между примесными атомами значительно больше постоянной решётки a , и они, в нек-ром приближении, подобны атомам идеального газа с магн. восприимчивостью χ , подчиняющимся *Кюри закону*. В роли магн. примесных атомов могут выступать атомы *переходных элементов, лантаноидов и актиноидов*, имеющие нескомпенсиров. электронный спин на f - или d -орбиталях (см. *Парамагнетизм*). Обменные эффекты при взаимодействии электронов проводимости или дырок с магн. примесными атомами приводит к возможности магн. фазовых превращений.

Наиб. изучены соединения типа $A^{II}M_xB^{VI}$ и $A^{IV}M_xB^{VI}$ (где A^{II} — Cd, Zn, Hg; A^{IV} — Sn, Pb, Ge; B^{VI} — S, Se, Te; M — Mn, Fe, Eu), имеющие структуру ZnS, вюрцита и NaCl. Магн. ионы в этих П. п. (M) не создают состояний в запрещённой зоне полупроводника (рис. 1) (или вблизи точки вырождения

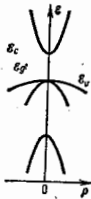


Рис. 1. Зонная диаграмма полупроводника InSb: E_g — ширина запрещённой зоны; E_c — дно зоны проводимости; E_v — потолок валентной зоны.

зоны проводимости и валентной зоны у *бесцелевых полупроводников*), однако отличие их потенциала от потенциала замещённых ими ионов приводит к изменению электронного спектра [ширины запрещённой зоны E_g (щели), эфф. массы носителей заряда m]. Наиб. исследованы как бесцелевые П. п. ($Hg_{1-x}Mn_xTe$

при $x < 0,07$ и $Hg_{1-x}Mn_xSe$ при $x < 0,06$), так и П. п. с узкой и широкой запрещёнными зонами ($Hg_{1-x}Mn_xTe$ при $x > 0,07$, $Cd_{1-x}Mn_xTe$, $Zn_{1-x}Mn_xSe$). Зависимости ϵ_{σ} от T и x для тв. растворов полупроводников $A^{II}B^{VI}$ хорошо описываются эмпирич. формулами (рис. 2):

$$Hg_{1-x}Mn_xTe \begin{cases} \epsilon_{\sigma} = -0,305 + 0,55T + 4,4x(10^{-3} \text{эВ}), \\ \frac{\partial \epsilon_{\sigma}}{\partial T} = 5,5 \cdot 10^{-4} (\text{эВ/К}), \end{cases}$$

$$Hg_{1-x}Mn_xSe \begin{cases} \epsilon_{\sigma} = -0,27 + 4,4x(эВ), \\ \frac{\partial \epsilon_{\sigma}}{\partial T} = 8,4 \cdot 10^{-4} (\text{эВ/К}). \end{cases}$$

Возможность варьировать в широких пределах состав П. п. (изменяя x) позволяет плавко перестраивать электронную структуру от бесцелевого инверсного спектра до обычного ($\epsilon_{\sigma} > 0$).

Энергетический спектр зонных носителей заряда. Специфич. свойства П. п. обусловлены обменным взаимодействием валонных носителей заряда с электронами магн. ионов. Гамильтониан этого взаимодействия

$$\mathcal{H}_{обм} = \sum_i \sum_j \hat{S}_i(r - R_j), \quad (1)$$

где \hat{S}_i — спиновые операторы зонных носителей и локализов. магн. моментов, $\int(r - R_j)$ — интеграл *обменного взаимодействия* валонных носителей с электронами магн. ионов (r — пространств. координата); суммирование ведётся по всем углам (R_j), занятым магн. ионами. Т. к. зонные носители взаимодействуют с большим числом локализов. магн. моментов, \hat{S}_i можно заменить его термодинамич. средним $\langle \hat{S}_i \rangle$, а суммирование по R_j — суммирование по всем углам, умножив сумму в (1) на долю узлов, занятых магн. ионами. При этом энергетич. спектр носителей в П. п. вблизи краёв разрешённых зон (ϵ_c и ϵ_v) можно получить, добавив к гамильтониану, записанному в k -р-приближении $\mathcal{H}_{обм}$. В отсутствие магн. поля $\langle \hat{S}_i \rangle = 0$, $\mathcal{H}_{обм} = 0$ и энергетич. спектр П. п. аналогичен спектру соответствующего обычного полупроводника. В магн. поле энергия обменного взаимодействия $\mathcal{H}_{обм} \neq 0$, что приводит к перестройке энергии, спектра носителей заряда. В полупроводниках с достаточно широкой запрещённой зоной энергетич. интервалы между соседними *Ландау уровнями* (орбитальное квантование энергии носителей) удовлетворяют условию $\hbar\omega_c \ll \epsilon_{обм}$ ($\omega_c = eH/mc$ — *циклотронная частота*). Тогда можно пренебречь орбитальным квантованием носителей, и обменное взаимодействие приводит лишь к аномально большому спиновому расщеплению зонных состояний. В узкощелевых и бесцелевых полупроводниках ($\hbar\omega_c \gg \epsilon_{обм}$) перестройка спектра значительно сложнее. Возникают особенности квантования *Ландау* в магн. поле. Напр., могут наступить вырождение и даже инверсия спиновых подуровней, относящихся к равным уровням *Ландау*. Особенно сильно обменное взаимодействие скажется на положении низшего электронного (ϵ_v) и высшего валентного (ϵ_c) уровней, к-рые при увеличении H могут перекреститься. К такому же эффекту приводит увеличение содержания Mn при фиксированных H и темп-ры T . Так, бесцелевой полупроводник $Hg_{1-x}Mn_xTe$ при включении магн. поля становится *полуметаллом* (пронсходит перекресток зоны проводимости и валентной зоны), а при дальнейшем увеличении H в нек-ром поле H_1 он превращается в обычный полупроводник со щелью (рис. 3).

Магнитные свойства П. п. существенно отличаются от свойств *магнитных полупроводников*. Они зависят от концентрации магн. ионов (x) и темп-ры (T). На фазовой диаграмме $x - T$ есть 3 области: парамагнитная, т. е. область спинового стекла и антиферромагнитная (рис. 4). В парамагн. области, к-рая соответст-

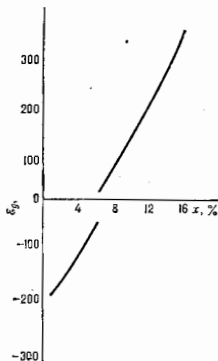


Рис. 2. Зависимость ширины запрещённой зоны E_g (в эВ) у $Hg_{1-x}Mn_xTe$ (верхняя) и у бесцелевого полупроводника $Hg_{1-x}Mn_xSe$ (нижняя) от содержания Mn .

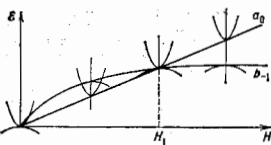


Рис. 3. Зависимость положения верхнего уровня валентной зоны σ и нижнего уровня зоны проводимости b_{-1} от магнитного поля в бесщелевых полупроводниках $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$.

вует малым x или высоким T , намагнитченность I описывается т. п. ф-цией Бриллюана $B(y)$:

$$I \propto -g_0 \mu_B \left[\frac{MH}{k(T+T_0)} \right], \quad (2)$$

$$B(y) = \frac{2y_0+1}{y_0} \operatorname{cth} \left(\frac{2y_0+1}{y} \right) - \frac{1}{2y_0} \operatorname{cth} \frac{y}{2y_0}.$$

Здесь y_0 , T_0 — феноменологич. параметры, учитывающие отличие I от намагнитченности идеального парамагнетика, к-рое обусловлено взаимодействием (обычно антиферромагнитным) соседних магн. ионов или более сложных комплексов.

При низких темп-рах и значит. x в П. п. наблюдается переход в фазу *спинового стекла* (напр., в $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ при $x > 0,17$; рис. 4). В бесщелевых П. п.

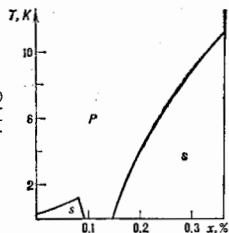


Рис. 4. Фазовая ($T-x$) диаграмма магнитного состояния $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$; P — парамагнитная фаза, S — область спинового стекла.

область спинового стекла может, по-видимому, существовать и при малых x , что связано с косвенным обменным взаимодействием магн. ионов через электроны проводимости. Антиферромагн. фаза обнаружена лишь в $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ при $x > 0,6$.

Локализационные состояния. Как и обычные полупроводники, П. п. могут быть легированы как донорами, так и акцепторами. Энергии локализованных примесных состояний в П. п. определяются не только кулоновским взаимодействием с потенциалом поля примесного центра, но и обменным взаимодействием с локализованными магнитными моментами, расположенными внутри борцовского радиуса примесного центра. Такое локализов. состояние наз. *связанным магнитным полароном*. Вклад обменного взаимодействия в энергию локализов. состояний зависит от концентрации магн. ионов (x), темп-ры (T) и магн. поля (H). В узкощелевых и бесщелевых П. п. зависимость энергии ионизации мелких примесей от H связана также со спецификой квантования зонных состояний (см. выше). Т. о., в П. п. энергия ионизации примесей, а следовательно, и кинетич. явления значительно сильнее зависят от H и T , чем в обычных полупроводниках.

Кинетические явления. Наиб. ярким проявлением роли обменного взаимодействия электронов с локализов. магн. ионами является гигантское отрицат. *магнетосопротивление* $\Delta\rho(H)$, наблюдаемое в узко-

щелевых П. п. р-типа (ρ уменьшается на 5—7 порядков в полях $H \sim 4-5$ Тл). Уменьшение ρ в магн. поле в ряде случаев сопровождается фазовым переходом полупроводник — металл (см. *Переход металл — диэлектрик*). Этот переход обусловлен уменьшением энергии ионизации акцепторных примесей и ростом радиуса волновой ф-ции акцепторных состояний в магн. поле из-за специфики квантования валентной зоны П. п. и разрушения состояний связанного магн. поларона. Др. особенность кинетич. явлений в П. п. — немонотонная зависимость амплитуды осцилляций Шубникова — де Хааса от H и T , обусловленная разл. вкладом обменного взаимодействия в энергию разных спиновых подуровней Ландау (см. *Квантовые осцилляции* в магнитном поле).

Оптические свойства. Специфика энергетич. спектра свободных и локализов. состояний носителей заряда в П. п. приводит к особенностям оптич. и магн.-оптич. явлений. В П. п. наблюдается гигантский *Фарадеев эффект* при энергиях фотонов, близких к энергии края фононов. Поглощения (в $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ *Верде постоянная* достигает 36000 град/см Тл), сильная зависимость от магн. поля стоксовского сдвига в спектрах комбинационного рассеяния света и расщепления линий поглощения свободных и связанных *экситонов*.

Лит.: Ляйпилья И. И., Цандильковский И. М., Узкощелевые полуметаллические полупроводники, *УФН*, 1985, т. 146, с. 35; Brandt N. B., Moschinskii V. V., Semimagnetic semiconductors, *Adv. Phys.*, 1984, v. 33, № 3, p. 193; Башкин Е. П., Спиновые волны и квантовые коллективные явления в полуметаллических газах, *УФН*, 1986, т. 148, в. 3, с. 433. Г. М. Мильков, И. М. Цандильковский.

ПОЛУМЕТАЛЛЫ — металлы, обладающие аномально малым числом ($10^2 - 10^3$) носителей заряда, приходящихся на один атом вещества. П. обладают всеми свойствами *металлов* при низких темп-рах T (вплоть до температуры носителей заряда, постоянством их концентрации вплоть до темп-р $T = 0$ К, характерном электропроводности). С др. стороны, ряд свойств П. делает их похожими на *полупроводники*: значительно более низкая электропроводность, чем у металлов; заметное возрастание числа носителей при повышении темп-ры. П. занимают промежуточное положение между металлами и полупроводниками.

П. являются элементы V группы периодич. системы элементов (As, Sb, Bi), графит и нек-рые соединения (GeTe и др.). Все П. имеют одинаковое число электронов и дырок и относятся к *компенсиров. металлам* с четным числом валентных электронов, приходящихся на элементарную ячейку кристалла.

Полуметаллич. состояние у элементов V группы возникает вследствие структурной неустойчивости металла с простой кубич. решеткой, являющегося своеобразной «прафазой» П. Этот «праметалл» обладает *ферми-поверхностью* с большими плоскими участками, размеры к-рых сопоставимы с размерами *Бриллюэна* зоны. При нормальных давлениях термодинамически более выгодной оказывается слабо искаженная ромбоэдрич. структура с удвоенным периодом в направлении одной из пространств. диагоналей исходного куба. Переход к искаженной структуре подобен *Пайерса переходу* в одномерных металлах (см. *Квазиодномерные соединения*). При высоких давлениях р металлич. прафаза оказывается устойчивой. Её восстановление при вестороннем сжатии экспериментально наблюдалось у Bi(BiII) при $p = 26$ кбар, у Sb(SbII) при $p = 78$ кбар.

В отличие от одномерного случая, где Пайерса переход приводит к образованию электронного энергетич. спектра диэлектрика с конечной величиной запрещенной зоны, в трёхмерном случае неустойчивость прафазы может приводить к образованию как диэлектрич. спектра, так и полуметаллического. Для последнего характерно перекрытие разрешенных зон. Оно оказывается возможным из-за четности числа атомов и валентных электронов в элементарной ячейке, возникающей в результате удвоения периода решетки (у П. V

группы элементарная ячейка содержит 2 пятивалентных атома и 10 валентных электронов).

Чистые As, Sb, Bi имеют полуметаллич. спектр. Силы As и Sb ($Bi_1 - Sb_2$) в интервале составов $0,065 \leq x \leq 0,23$ являются полупроводниками с узкой запрещенной зоной $E_g \leq 0,025$ эВ.

Новую парадокс имеет происхождение полуметаллич. состояния в графите. Атомы C в отд. слое графита расположены в вершинах правильных шестиугольников и образуют структуру с полностью насыщенными связями. Электронный энергетич. спектр такого слоя является спектром *бесщелевого полупроводника*. Слабое перекрытие волновых ф-ций электронов в соседних слоях приводит к возникновению полуметаллич. спектра трёхмерного графита с перекрытием зон $\sim 0,04$ эВ.

Анализ происхождения электронного энергетич. спектра П. позволяет понять, с чем связано наиб. характерное для всех П. свойство — малое число носителей заряда на один атом вещества. Столь же типично для П. малое значение эфф. масс m электронов и дырок в нек-рых направлениях в зоне Бриллюэна ($10^{-2} - 10^{-8}$ от массы m_0 свободного электрона).

Совершенство этих свойств обуславливает то, что целый ряд физ. параметров П. имеет аномально значение. Вследствие малого числа носителей весьма малыми являются сечения поверхности Ферми ($S \sim 10^{-40} - 10^{-48}$ г.а.см²/с²). Малость эфф. масс приводит к высокой подвижности μ носителей заряда (при низких темп-рах $\mu \approx 10^6 - 10^7$ см²/В.с), к большим значениям коэф. магнетосопротивления ($\Delta\rho/\rho H^2 \sim 10^{-2} - 10^{-8}$ З²), термоэдс ($\alpha \sim 10^{-4}$ В/град), g -факторов ($\sim 10^2 - 10^3$), магнитной восприимчивости χ .

Диэлектрич. проницаемость ϵ у П. В группы велика ($\epsilon \geq 10^3$). Такая величина ϵ связана с тем, что при удалении по энергии от уровня Ферми E_F на величину $\sim 0,1$ эВ электронный энергетич. спектр этих веществ мало отличается от спектра в парафазе, для к-рого характерна большая плотность электронных состояний.

У графита подобная аномалия отсутствует ($\epsilon \sim 2,5$). Полуметаллы V группы. Кристаллич. решётка имеет симметрию $R\bar{3}m$ (D_{6h}^{17}) (см. Симметрия кристаллов). Она отличается от простой кубич. решётки ромбоэдрич. деформацией (угл. искажения $\sim 3^\circ - 5^\circ$) и сдвигом двух граней кубов, подрешётки вдоль выделенной диагонали куба (относит. сдвиг 10%). Зона Бриллюэна близка по форме к зоне Бриллюэна для граней кубов, кубич. решётки. Выделенное направление — ось 3-го порядка C_3 (рис. 1). Электронные

сильно различаются между собой. У Vi поверхности Ферми дырок представляют собой эллипсоид вращения, вытянутый вдоль оси C_3 с центром в точке Γ зоны Бриллюэна (рис. 2). Отношение экстремальных дырочных сечений в Vi близко к 3. У Sb 6 дырочных экстремумов, расположенных в точках H зоны Бриллюэна (рис. 3).

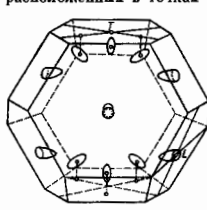


Рис. 3. Электронная и дырочные части поверхности Ферми Sb.

ответствующими поверхностями у Sb и Vi.

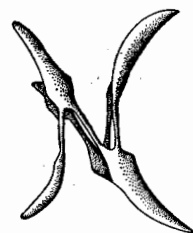


Рис. 4. Дырочная поверхность Ферми As.

Поверхности Ферми дырок — эллипсоиды вращения, направленные вытянутости к-рых составляют углы $\sim 37^\circ$ с осью C_3 , степень анизотропии экстремальных сечений близка к 3. Дырочные экстремумы в As находятся в тех же точках, что и в Sb, но поверхность Ферми дырок имеет значительно более сложную форму (рис. 4), что связано с большими размерами поверхности Ферми у As в зоне Бриллюэна по сравнению с соответствующими поверхностями у Sb и Vi.

Эфф. массы электронов в П. В группы анизотропны: они близки к m_0 в направлении вытянутости поверхности Ферми, тогда как в перпендикулярных направлениях $m = 10^{-2} m_0$. Эфф. массы дырок у Vi слабо анизотропны и составляют $\sim 10^{-1} m_0$. У As и Sb дырочные массы более анизотропны и составляют $\sim (10^{-1} - 10^{-2}) m_0$.

Графит. Кристаллич. решётка относится к гексагональной системе, описывается пространств. группой симметрии $R\bar{6}m_2 C_6$ (C_{6h}^{12}). Выделенное направление (ось C) перпендикулярно слоям в решётке.

Расстояние между атомами углерода в слое при $T = 300$ К $a = 1,415$ А, межслоевое расстояние $c/2 = 3,5338$ А. Зона Бриллюэна — гексагональная призма (рис. 5). Ось k_z совпадает с выделенным направле-

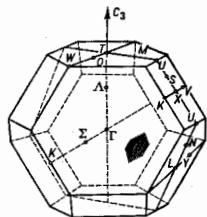


Рис. 1. Первая зона Бриллюэна полуметаллов V группы.

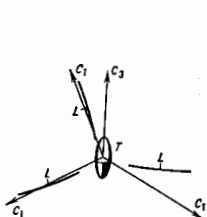


Рис. 2. Дырочные части поверхности Ферми Bi.

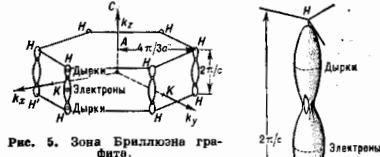


Рис. 5. Зона Бриллюэна графита.

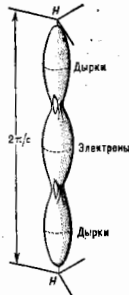


Рис. 6. Электронные и дырочные части поверхности Ферми графита.

части поверхности Ферми у всех П. В группы представляют собой 3 вытянутые поверхности, близкие по форме к эллипсоидам (отношение макс. и мин. сечений $\sim 12-16$) с центрами в точках L зоны Бриллюэна (рис. 2). Направления вытянутости квазиэллипсоидов у As и Sb отклонены на малые углы ($2-6^\circ$) от базисной плоскости и соответствующих бисектрисных осей C_1 . Дырочные части поверхности Ферми у П. В группы

нием C . Поверхности Ферми сильно анизотропны. Её электронные и дырочные части вытянуты вдоль боковых рёбер HKH зоны Бриллюэна и близки по форме к гофрированным в базисной плоскости эллипсоидам (рис. 6). Отношение экстремальных сечений поверхности Ферми для электронов и дырок ~ 10 .

В отличие от П. V группы электронные (с центром в точках К зоны Бриллюэна) и дырочные участки поверхности Ферми сопрягаются между собой. В малой окрестности точек сопряжения поверхности близки и ковыпеским. Эфф. массы электронов и дырок вдоль оси C : $m \approx m_0$, в плоскости графитовых слоев $m \approx 10^{-2} m_0$. Кроме описанных частей поверхности Ферми, к-рые относятся к т. в. осн. носителям заряда вблизи точек К и H в зоне Бриллюэна расположены изоэнергетич. поверхности малых групп электронов и дырок (неосновные носители).

Физические свойства полуметаллов

Электропроводность. Высокая подвижность μ носителей в П. частично компенсирует малость их концентрации. В результате электропроводность σ П. значительно меньше отличается от проводимости металлов, чем концентрация носителей заряда ($\sigma = 2 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10^4 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при $T = 300 \text{ К}$ и $10^4 - 10^7 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при впаках темп-ры). Высокие значения μ и равенство концентраций электронов и дырок приводит к аномально сильной зависимости уд. сопротивления П. от магн. поля H. Напр., у Bi при $T = 4,2 \text{ К}$ уд. сопротивление ρ возрастает в 10^4 раз в поле $H = 10^4 \text{ Э}$. При $T = 300 \text{ К}$ в том же поле наблюдается двукратное увеличение ρ у Bi, тогда как у Si изменение ρ при тех же условиях составляет 10^{-4} (см. *Гальваномагнитные явления. Магнетосопротивление*). При впаках темп-ры магнетосопротивление $\Delta\rho/\rho$ обнаруживает осциллирующую зависимость от обратного магн. поля $1/H$ (*Шубникова — Де Хааса эффект*). Сильная зависимость сопротивления ρ от H широко используется для создания датчиков магн. поля.

Магнитные свойства полуметаллов. Все П. — диамагнетики. Определяющий вклад в величину магн. восприимчивости χ вносят электроны валентной зоны. Малость χ обуславливает большое значение χ , к-рая для П. достигает макс. значения среди всех известных диамагнетиков (исключая сверхпроводники, у к-рых $|\chi| = 1/4\pi$).

При впаках темп-ры у П. наблюдается осциллирующая зависимость χ от $1/H$ (*Де Хааса — ван Алфена эффект*). В наиб. чистых монокристаллах П. амплитуда осцилляций превосходит величину монотонной части, иногда достигает теоретически возможного предела $|\chi| = 1/4\pi$. В последнем случае в кристалле возникает своеобразная структура доменов. Среди П. макс. диамагнетизмом обладает графит (особенно искусственно квадрупольные графиты с увеличенным междоузельным расстоянием). Высокий диамагнетизм П. (в частности, графита и Bi) позволяет их использовать для создания магнитных подвесов.

Термоэлектрические свойства. С малостью энергии Ферми E_F , большой подвижностью μ носителей и заметным различием подвижностей электронов и дырок связаны высокие значения термоэфф. П. (α) и её сильная зависимость от магн. поля H (см. *Термогальваномагнитные явления*). С этим же связана большая величина т. п. термоэлектрич. добротности Z. В частности, у сплавов Вb — Sb при $T = 77 \text{ К}$ величина Z достигает значения $\sim 6 \cdot 10^{-2} \text{ град}^{-1}$ и увеличивается до $10^{-2} \text{ град}^{-1}$ в поле $H \sim 10^4 \text{ Э}$ (*Нернста — Эттингсхаузена эффект*). Высокая термоэлектрич. и термоагн. добротности позволяют использовать П. в качестве материалов для создания термоэлектрич. преобразователей или твердотельных холодильных устройств.

Чувствительность полуметаллов к внешним воздействиям. Малость энергий Ферми E_F электронов и дырок и энергии перекрытия зон является причиной того, что электронный спектр П. может претерпевать значит. изменения под действием разл. внеш. факторов (неэластичное сжатие, одноосные деформации, сильные магн. поля, изменение темп-ры, внесение примесей и т. д.). Чувствительность электронного энергетич. спектра П. относительно слабым внеш. воздействиям

позволяет наблюдать в них большое число эффектов, имеющих принципиальное значение в физике твердого тела. В П. V группы и их сплавов под давлением, при одноосных деформациях, легирования донорными или акцепторными примесями обнаружены фазовые переходы, к-рые связаны с изменением топологии и формы поверхности Ферми (топологич. переходы). Частным случаем таких переходов является *переход металл — диэлектрик*, к-рый сопровождается исчезновением поверхности Ферми электронов и дырок. Такой переход в П. V группы наблюдается под давлением, при одноосных деформациях и в магн. поле (у графита — в магн. поле). Вблизи критич. точки перехода металл — диэлектрик в П. в сильных магн. полях наблюдаются дилатризация спектра в результате электронно-дырочного сраивания и образование фаз *экстремального диэлектрика*. В П. V группы происходят переходы в состояние бесщелевого полупроводника, к-рые сопровождаются реаким уменьшения эфф. масс носителей, возрастанием их подвижности и автотриции поверхности Ферми. В П. впервые обнаружены гигантские осцилляции поглощения ультрафиолета в магн. поле, разл. виды магнитоплазменных волн (альфавенские, циклотронные волны, доллероны), скачущие траектории электронов в магн. поле (*магнитные поверхностные уровни*), *циклоотронный резонанс*, радиочастотный размерный эффект (см. *Гантмахера эффект*), разл. осцилляц. эффекты, фокусировка электронов и т. п.

Лит.: Фальковский Л. А., Физические свойства висмута, «УФН», 1968, т. 94, с. 3; Бранд Н. Б., Инкельвич Е. С., Минина Н. Я., Влияние давления на поверхность Ферми металлов, «УФН», 1971, т. 124, с. 459; Абрамов А. А., Некоторые вопросы теории полуметаллов, «ЖЭТФ», 1973, т. 65, с. 2083; Эдельман В. С., Свойства электронов в висмуте, «УФН», 1977, т. 123, с. 257; Крайнев А. У., Уолли К. В., Поверхность Ферми, пер. с англ., М., 1978; Слагтер Р. U., Heer G., High pressure properties of graphite and its intercalation compounds, «Adv. Phys.», 1984, v. 33, № 5, p. 469; Brand N. B., Chudinov S. M., Popov I. A., G. G., Semiletal I. I., Graphite and its compounds, Amsterdam, 1988. С. М. Чубин, С. Д. Бемельский.

ПОЛУПРОВОДНИКИ — широкий класс веществ, в к-рых концентрация подложных носителей заряда значительно ниже, чем концентрация атомов, и может изменяться под влиянием темп-ры, освещения или относительно малого кол-ва примесей. Эти свойства, а также увеличение проводимости с ростом темп-ры, качественно отличают П. от металлов. Различие между П. и диэлектриками носит условный характер, к диэлектрикам обычно относят вещества, уд. сопротивление ρ в к-рых при комнатной темп-ре ($T = 300 \text{ К}$) $\geq 10^{11} - 10^{12} \text{ Ом} \cdot \text{см}$.

По структуре П. делятся на кристаллические, аморфные и стеклообразные, жидкие. Особый класс составляют *твердые растворы* П., в к-рых атомы разных сортов хаотически распределены по узлам правильной кристаллич. решетки. Ниже рассматриваются кристалл. П.

По хим. составу П. делятся на элементарные П. (Ge, Si, Se, Te), двойные, тройные, четверные соединения. Существуют также органич. П. (см. *Органические проводники*). Полупроводниковые соединения принято классифицировать по номерам групп периодич. табл. элементов, к к-рым принадлежит входящие в соединение элементы. Напр., соединения $A^{IV}B^{IV}$ содержат элементы 3-й и 5-й групп (GaAs , InSb и т. д.). Элементы Ge, Si, соединения $A^{III}B^{V}$ и их твердые растворы играют важную роль в полупроводниковой электронике. Хорошо изучены также полупроводниковые соединения $A^{II}B^{VI}$ и $A^{IV}B^{VI}$ (см. *Полупроводниковые материалы*).

Зонная структура полупроводников

Электрич. в оптич. свойства П. связаны с тем, что заполненные электронами состояния (уровни энергии) отделены от вакантных состояний запрещенной зоной, в к-рой электронные состояния отсутствуют (рис. 1). Примеси и дефекты структуры приводят к появлению

состояний в запрещенной зоне, по этим состояниям сравнительно мало, так что понятие запрещенной зоны сохраняет смысл. Высшая целиком заполненная зона наз. валентной, следующая разреженная, но пустая зона — зоной проводимости (см. *Твердое тело, Зонная теория*).

Рис. 1. Зонная схема полупроводника (состояния, заполненные электронами, заштрихованы).



Ширина запрещенной зоны E_g является важной характеристикой П., в значит. мере определяющей все его электронные свойства; величина E_g изменяется в широких пределах (табл. 1).

Табл. 1. — Ширина запрещенной зоны некоторых полупроводников при $T=300$ К

Полупроводник	E_g , эВ	Полупроводник	E_g , эВ
Ge	0,65	InP	1,26
Si	1,10	GaSb	0,67
Se	1,89	GaAs	1,35
InSb	0,17	GnP	2,24
InAs	0,35	AlSb	1,60

Существуют *бесщелевые полупроводники*, у к-рых $E_g = 0$ (напр., α -Sn, HgTe, HgSe); у твердых растворов, включающих эти П. (напр., $Hg_{1-x}Cd_xTe$), E_g может принимать очень малые значения.

Состояние электрона в П. характеризуется номером разрешенной зоны s и квазиимпульсом p . Структура зоны определяется зависимостью энергии ϵ_s от квазиимпульса p : $\epsilon_s(p)$, наз. законом дисперсии (в дальнейшем, говоря о конкретной зоне, индекс s опускаем). Если валентная зона целиком заполнена электронами, то в ней нет элементарных возмущений. Если по к.-л. причине в валентной зоне отсутствует электрон, то говорят, что в ней появилось возмущение в виде положительно заряженной квазичастицы — дырки. Носителями заряда в П. являются электроны в зоне проводимости (электроны проводимости) и дырки в валентной зоне.

Энергетические зоны. Зоны проводимости типичных П. (Ge, Si, $A^{III}B^V$) не имеют вырождения вблизи минимума ф-ции $\epsilon(p)$ (не считая двухкратного вырождения по спину). У нек-рых П. минимум $\epsilon(p)$ нахо-

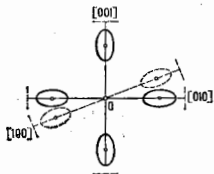


Рис. 2. Расположение изоквантовых поверхностей энергетических зон в зоне Бриллюэна для Si (пунктир — граничные зоны).

дится при $p = 0$, т. е. в центре Бриллюэна зоны. В малой окрестности этой точки можно разложить $\epsilon(p)$ в ряд по степеням p . При этом для кристаллов с кубич. симметрией можно ограничиться первыми двумя членами, что приводит к зависимости:

$$\epsilon(p) = \epsilon_c + p^2/2m_1 \quad (1)$$

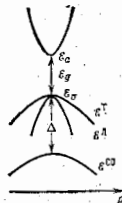
Здесь ϵ_c — энергия, соответствующая «дну» зоны проводимости, m_1 — постоянная, имеющая размерность массы. Для электронов с не очень большой энергией, для к-рых применим закон (1), величина m_1 фигурирует в ур-ниях движения как масса электрона. Поэтому она наз. *эффективной массой*. Напр., если электрон находится в потенциальном поле, причём характерный размер, на к-ром изменяется поле, велик по сравнению с постоянной решётки a_0 , то уровни энергии и волновые ф-ции электрона можно находить с помощью *Шрёдингера уранения*. При этом не нужно учитывать периодич. потенциал, создаваемый атомами кристалла, а нужно лишь заменить массу свободного электрона в вакууме m_0 на эфф. массу m_1 (метод эфф. массы). Т. о., при малых энергиях эфф. масса определяет динамику электронов (табл. 2).

Закон дисперсии (1) является параболическим (квадратичным) изотропным в наз. стандартах. Изокванты поверхности в импульсном пространстве $\epsilon(p) = \text{const}$ вблизи $p = 0$ представляют собой сферы с центром в точке $p = 0$.

Если минимум $\epsilon(p)$ находится не в центре зоны Бриллюэна, а при $p \neq 0$, то эфф. масса m_1 зависит от направления относительно кристаллографич. осей (осей симметрии кристалла), т. е. является тензором m_{ij} , даже в кристаллах с кубич. симметрией.

В этом случае должно существовать нек. минимумов, расположенных в симметричных (эквивалентных) точках зоны Бриллюэна. Напр., зона проводимости таких П., как Ge и Si, имеет нек. минимумов. В Si один из них расположен в направлении $[100]$ на расстоянии от центра зоны Бриллюэна ($p = 0$) $p^0 = 0,85(2\pi\hbar a_0)$. Поверхности пост. энергии $\epsilon(p) = \text{const}$ представляют собой эллипсоиды вращения вокруг направления $[100]$ (рис. 2). Кубич. симметрия

Рис. 3. Зависимость энергии ϵ от квазиимпульса p для типичных полупроводников: ϵ_1 — электронная зона; ϵ_2 — дырочные зоны: ϵ_2^1 — зона тяжёлых дырок; ϵ_2^2 — зона лёгких дырок; ϵ_2^3 — спин-орбитально отщеплённая зона.



кристалла требует, чтобы такие эллипсоиды существовали в каждом из 6 эквивалентных направлений. Т. о., в Si есть 6 эквивалентных минимумов $\epsilon(p)$. Выбирая ось z вдоль $[100]$, получим выражение для энергии электронов проводимости вблизи минимума $\epsilon(p)$:

$$\epsilon(p) = \frac{(p_x - p_x^0)^2}{2m_1} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m_2} \quad (2)$$

Для Si $m_1 = 0,91m_0$, $m_2 = 0,19m_0$, где m_1 , m_2 — эфф. массы вдоль и поперёк z .

Минимумы зоны проводимости Ge (соответствующие ϵ_c) расположены в направлениях пространств. диагоналей куба точно на границах зоны Бриллюэна. По-

этом каждый минимум принадлежит двум зонам Бриллюэна и их число вдвое меньше числа эквивалентных направлений, т. е. равно 4. Поверхности $\epsilon(p) = \text{const}$ имеют вид эллипсоидов с осями вращения вдоль диагоналей куба; $m_{11} = 1,58 m_0$, $m_1 = 0,08 m_0$.

Области энергии вблизи каждого минимума наз. долинами, а П. с неск. эквивалентными минимумами наз. многодолинными (см. *Многодолинные полупроводники*).

Вырожденные зоны. Валентная зона типичных П. (Ge, Si, A^{III} V) в точке $p = 0$ без учёта спин-орбитального взаимодействия шестикратно вырождена. Однако благодаря спин-орбитальному взаимодействию зона расщепляется в точке $p = 0$ на двукратно и четырёхкратно вырожденные зоны (рис. 3). Энергетич. расстояние между ними Δ наз. энергетич. спин-орбитального расщепления. При $p \neq 0$ 4-кратное вырождение снимается и возникает 2 двукратно вырожденные зоны, к-рые наз. зонами лёгких (ϵ^L) и тяжёлых (ϵ^T) дырок. Их энергия зависит от квазиимпульса, определяемого выражением:

$$\epsilon^{L,T} = -\frac{1}{2m_0} \left\{ \gamma_1 p^2 \pm \left[4\gamma_2 p^4 + 12 \left(\gamma_3 - \gamma_2^2 \right) \left(\frac{p_x^2}{\gamma_x} + \frac{p_y^2}{\gamma_y} + \frac{p_z^2}{\gamma_z} + p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right) \right]^{1/2} \right\}, \quad (3)$$

где знак плюс соответствует зоне лёгких дырок, знак минус — зоне тяжёлых дырок; $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ — безразмерные параметры (параметры Латтинджера; табл. 3).

Табл. 3. — Параметры Латтинджера и энергии спин-орбитального расщепления Δ (эВ) для Ge и Si

Полупроводник	γ_1	γ_2	γ_3	Δ
Si	4,22	0,39	1,44	0,04
Ge	13,35	4,25	5,69	0,29

Поверхности $\epsilon(p) = \text{const}$, описываемые выражением (3), не обладают сферич. симметрией. Это слегка «гофрированные» сферы. В ряде П., в т. ч. и в Ge, аннизотропия изоэнергетич. поверхностей слабая. Поэтому зоны лёгких (л) и тяжёлых (т) дырок приближённо описываются ур-ниями

$$\epsilon^L = -p^2/2m^L, \quad \epsilon^T = -p^2/2m^T, \quad (4)$$

где $m^L = m_0(\gamma_1 + 2\gamma_2)^{-1}$ — масса лёгкой дырки, $m^T = m_0(\gamma_1 - 2\gamma_2)^{-1}$ — масса тяжёлой дырки, $\gamma = (3\gamma_2 - 2\gamma_1^2)/5$. Для Ge $m^L = 0,04 m_0$, $m^T = 0,3 m_0$. Если пренебречь переходами между зонами лёгких и тяжёлых дырок, то m^L и m^T описывают динамику лёгких и тяжёлых дырок. Описанная картина валентных зон точна для кристаллов Ge и Si, обладающих центром инверсии. В кристаллах П. типа A^{III} V при малых p закон дисперсии имеет более сложный вид.

Модель Кейна. Кинетич. энергия ϵ электрона или дырки параболически (квадратично) зависит от их квазиимпульса p при условии, что она мала по сравнению с ϵ_g . В узкозонных П. (ϵ_g мало) это условие нарушается. Однако для закона дисперсии и при $\epsilon > \epsilon_g$ можно получить простые выражения, к-рые справедливы при условии, что длина волны электрона велика по сравнению с постоянной решётки a_0 . При этом, как правило, энергетич. расстояние до следующих разрешённых зон остаётся всё ещё значительно больше, чем энергия электрона. В этом случае следует учитывать только перемешивание волновых ф-ций электронных зон проводимости и валентной зоны, взаимодействие же с др. зонами несущественно. Такое приближение наз. моделью Кейна. Кроме величин ϵ_g и Δ в нём фигурирует лишь один параметр P , характеризующий перемешивание волновых ф-ций, к-рый выражается через эфф. массу электрона на «двух» зонах проводи-

мости ϵ_c . При предельно малых импульсах p , когда $\epsilon \ll \epsilon_g$, модель Кейна даёт следующие параболич. выражения для энергии электронов $\epsilon^e(p)$, лёгких дырок $\epsilon^L(p)$, тяжёлых дырок $\epsilon^T(p)$ и дырок в спин-орбитально отщеплённой зоне $\epsilon^{CO}(p)$:

$$\begin{aligned} \epsilon^e &= \frac{p^2 p^2}{3\hbar^2} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_0 \sigma^* \Delta} \right); \\ \epsilon^L &= -\frac{2p^2 p^2}{3\hbar^2 \epsilon_0}, \quad \epsilon^T = 0; \\ \epsilon^{CO} &= -\Delta - \frac{p^2 p^2}{3\hbar^2 (\epsilon_0 \sigma^* \Delta)}. \end{aligned} \quad (5)$$

Как видно из (5), это приближение не позволяет найти энергетич. спектр тяжёлых дырок. Если $\epsilon_g \ll \Delta$, то, сопоставив (5) с (4) и (4), получим, что массы электрона и лёгкой дырки одинаковы и равны:

$$m = 3\hbar^2/4P^2 \epsilon_g. \quad (6)$$

Если при атом $p \ll \sqrt{2m\Delta}$, то энергетич. спектры электронов и лёгких дырок описываются ф-лами

$$\begin{aligned} \epsilon^e &= \frac{\epsilon_c}{2} \left(1 + 4 \frac{p^2}{2m\epsilon_0} \right)^{1/2}, \\ \epsilon^L &= \frac{\epsilon_c}{2} - \frac{\epsilon_c}{2} \left(1 + 4 \frac{p^2}{2m\epsilon_0} \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (7)$$

Ф-лы (7) показывают, что спектр электронов и лёгких дырок отклоняется от квадратичного, когда кинетич. энергия электрона или дырки порядка ϵ_g .

Примеси и дефекты в полупроводниках

Различают примеси электрически активные и неактивные. Первые способны приобретать в П. заряд того или др. знака, к-рый компенсируется появлением электрона в зоне проводимости или дырки в валентной зоне. Электрически неактивные примеси остаются нейтральными и сравнительно слабо влияют на электрич. свойства П. Как правило, электрич. активность связана с тем, что примесный атом имеет иную валентность, чем замещаемый атом, а кристаллич. решётка, в к-рую попадает примесь, аннгирует ей свою координацию ближайших соседей. Так, напр., элемент V группы, попадая в решётку Si с тетраэдрич. координацией, «перестраивает» свои валентные электроны так, что 4 из них образуют устойчивую тетраэдрич. конфигурацию, а 5-й электрон связан с примесным атомом относительно слабо. В первом приближении можно считать, что на атом «лишней» электрон действует лишь сила электростатич. притяжения к примесному иону, уменьшенная в ϵ раз (ϵ — диэлектрич. проницаемость решётки).

В простейшем случае неварожденной (стандартной) зоны ур-ние движения для лишнего электрона оказывается таким же, как для электронов в атоме водорода. Энергия связи имеет вид

$$\epsilon_0 = \frac{me^4}{2e^2 \hbar^2 \epsilon} = \frac{m_0 e^4}{2\hbar^2 \epsilon} \left(\frac{m}{m_0} \right)^{-1}, \quad (8)$$

где e — заряд электрона, ϵ — диэлектрич. проницаемость решётки. Если $m/m_0 = 10$, а $\epsilon = 12$, то ϵ_0 оказывается примерно в $1,5 \cdot 10^3$ раз меньше, чем энергия связи атома водорода (13,6 эВ). Тепловое движение легко отрывает электрон от примесного атома, после чего он может участвовать в переносе электрич. тока. Такие примесные атомы наз. донорами и (*донорная примесь*).

Элементы III группы, попадая в тетраэдрич. решётку, захватывают электрон из валентной зоны и с его помощью образуют устойчивую тетраэдрич. конфигурацию. Образовавшись в валентной зоне дырка притягивается к отрицательно заряженному примесному атому и при низких темп-рах находится в связанном (локализованном) состоянии. Энергия связи дырки

в случае стандартной зоны также выражается ф-лой (8), где m — эфф. масса дырки. Дырка, которая является от примесного атома, также может участвовать в переносе тона. Примесные атомы, поставляющие дырки, наз. акцепт. п. о. р. а. м. (акцепторная примесь).

На межатомных расстояниях потенциал, создаваемый примесным ионом, существенно отличается от потенциала точечного заряда и зависит от хим. природы примеси. Эта короткодействующая часть примесного потенциала создаёт дополнительное по отношению к ф-ле (8) смещение примесного уровня, называемое хим. м. с. д. в. г. м. Благодаря хим. сдвигу примесные уровни равных примесей отличаются друг от друга. Для s -состояний отличие значительно сильнее, чем для p -состояний, т. к. волновая ф-ция p -состояний равна 0 в примесном центре.

Если зона содержит нек. эквивалентных экстремумов (напр., состоит из нек. эквивалентных аллоспиродов), то примесные уровни имеют дополнит. вырождение, кратное s -рого равна числу эквивалентных экстремумов. В Ge, напр., вырождение донорного состояния четырёхкратное, в Si — шестикратное. Это вырождение частично снимается за счёт короткодействующей части примесного потенциала — в Ge инициальный уровень расщепляется на 2 уровня, в Si — на 3 (табл. 4). Теоретич. значения, приве-

Табл. 4. — Энергия связи донорных состояний в Si и Ge, в МэВ

Полупроводник	ϵ_0^{II}	ϵ_0^{III}
Si (теория)	31,27	11,51
Si (P)	45,5; 33,9; 32,6	11,45
Si (As)	53,7; 32,6; 31,2	11,43
Si (Sb)	42,7; 32,9; 30,6	11,52
Ge (теория)	9,81	4,74
Ge (P)	12,9; 9,9	4,75
Ge (As)	14,17; 10,0	4,76
Ge (Sb)	10,32; 10,0	4,74

дённые в табл., не учитывают хим. сдвиг. Эксперим. значения соответствуют примесям, символ k -рых указан в скобках. Состояние $2p$ соответствует нулевому значению магн. квантового числа, но к-рому в случае стандартной зоны вырождение отсутствует (ϵ_0^{II} соответствует основному состоянию примеси).

Акцепторные состояния в случае вырожденной валентной зоны обладают определ. спецификой. Если спин-орбитальное расщепление Δ велико по сравнению с энергией связи ϵ_0 акцептора, то двукратно вырожденную отщеплённую зону можно не принимать во внимание. Если пренебречь g -факторной изозергетич. поверхностью, то акцепторные состояния классифицируются по значениям полного момента кол-ва движения I и его проекции на ось квантования. Осн. состоянием оказывается четырёхкратно вырожденное состояние с $I = 3/2$.

Во мн. П. $m^* \gg m^0$. В этом случае волновая ф-ция примесного электрона содержит 2 разных масштаба, представляющих собой дыры волье де Бройля для частиц с одной энергией, но разными эфф. массами. По мере удаления от примесного центра волновая ф-ция определяется сначала меньшим масштабом, соответствующим тяжёлым дыркам, а затем большим масштабом, соответствующим лёгким дыркам. Энергия связи определяется тяжёлой массой. Её можно получить из ф-лы (8), заменив m на m^* и добавив численный множитель ϵ_0 .

Примесные состояния, у k -рых энергия связи ϵ_0 мала по сравнению с ϵ_g , наз. мелкими. Глубокие состояния, как правило, возникают, когда осн. вклад в энергию связи даёт не электрон, а притяжение, ослабленное диэлектрич. проницаемостью ϵ , а короткодействующий потенциал, k -рый определяется хим. природой

примеси (см. выше). Мелкие донорные состояния можно считать отщеплёнными от зоны проводимости, а мелкие акцепторные состояния — от валентной зоны. Глубокие состояния принадлежат в равной мере обеим зонам и могут быть и донорными и акцепторными.

В зависимости от кол-ва и вида примесей соотношение между концентрациями электронов и дырок может быть разным (см. ниже). Частицы, представленные в большинстве, на ос. носителями заряда, в меньшинстве — несносными. Доноры, введение примесей позволяют получать П. с требуемыми свойствами (см. *Легирование полупроводников*).

Если примесный атом замещает в решётке атом, принадлежащий той же группе периодич. системы (изоэлектронное замещение), то чаще всего он не образует локализов. электронное состояние. Такие примеси электрически неактивны. Они могут входить в решётку в очень больших кол-вах и образовывать твёрдые растворы. В твёрдых растворах расположение узлов решётки обладает дальним порядком, но атомы замещения располагаются в этих узлах хаотически.

Твёрдые растворы чрезвычайно важны для полупроводниковой электроники, т. к. в них можно менять ϵ_g за счёт изменения состава. Т. о., можно получить ряд кристаллов с непрерывно меняющейся ϵ_g и даже кристаллы, в k -рых ϵ_g меняется от точки к точке. Однако твёрдые растворы представляют собой неупорядоченные системы. Их состав неизбежно меняется от точки к точке, что приводит к размытию краёв зон и к специфич. рассеянию носителей заряда (см. также *Гетеропереход, Гетероструктура*).

Дефекты решётки в П. также могут быть электрически активными и неактивными. Важную роль играют вакансии, межузельный атом, дисокация.

В некристаллич. и жидких П. примеси ведут себя иначе, чем в кристаллических. Отсутствие кристаллич. структуры приводит к тому, что примесный атом иной валентности, чем замещаемый, может намыслить свои валентные связи, так что ему будет невыгодно присоединять лишней электрон или отдавать свой электрон. В результате примесный атом оказывается электрически нейтральным. Это обстоятельство не позволяет менять пункт легирования тип проводимости, что необходимо, напр., для создания $p-n$ -переходов. Некоторые аморфные П. изменяют электронные свойства под действием легирования, но в значительно меньшей степени, чем кристаллич. П. Чувствительность аморфных П. к легированию может быть повышена технol. обработкой. Насыщение аморфного Si водородом и последующее легирование донорами или акцепторами обеспечивает n - или p -тип проводимости. Таким способом получают $p-n$ -переход в плёнках аморфного Si; аморфный Si стал перспективным материалом для солнечных батарей (см. *Аморфные и стеклообразные полупроводники, Жидкие полупроводники*).

Статистика электронов в полупроводниках. Условие нейтральности

В состоянии термодинамич. равновесия концентрации электронов и дырок однозначно определяются темп-рой, концентрацией электрически активных примесей и параметрами зонной структуры. При расчёте концентраций электронов и дырок учитывается, что электрон может находиться в зоне проводимости, на донорном или акцепторном уровнях, а также то, что небольшая часть электронов в результате теплового «заброса» или др. воздействия может покинуть валентную зону, вследствие чего в ней образуются дырки.

Электроны подчиняются Ферми — Дирака статистике, и их распределение по энергиям ϵ описывается ф-цией Ферми, содержащей в качестве параметров состояния темп-ру T и химический потенциал μ . Иногда его наз. уровнем Ферми и обозначают ϵ_F . Вероятность заполнения уровня с энергией ϵ равна:

$$\{[1 + \exp(\epsilon - \epsilon_F)]/kT\}^{-1}.$$

При не очень большой концентрации примесей уровень Ферми ϵ_F оказывается в запрещенной зоне (рис. 4). При этом поведение подвижных электронов в дырок описывается законами классич. статистики (см. Максвелла распределение). Концентрация электронов в зоне

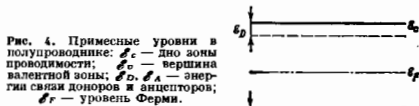


Рис. 4. Примесные уровни в полупроводнике: ϵ_c — дно зоны проводимости; ϵ_d — верхняя валентной зоны; ϵ_d , ϵ_a — энергии связи доноров и акцепторов; ϵ_F — уровень Ферми.

проводимости (n) и дырок в валентной зоне (p) определяются соотношениями (ϵ_F отсчитывается от «дна» зоны проводимости ϵ_c):

$$n = N_c \exp(\epsilon_F/kT), \quad (9)$$

$$p = N_v \exp[-(\epsilon_c + \epsilon_F)/kT], \quad (10)$$

где N_c и N_v — характерные концентрации электронов и дырок, определяемые их спектром при стандартном законе дисперсии. При стандартном спектре с эфф. массами электронов и дырок m^* и m^{\ddagger}

$$N_c = (2\pi m^* kT)^{3/2} / 4\pi^2 \hbar^3, \quad (11)$$

$$N_v = (2\pi m^{\ddagger} kT)^{3/2} / 4\pi^2 \hbar^3.$$

Для случая аллоисоэлектронных энергетич. поверхностей следует заменить m^* на $(m_1 m_2 m_3)^{1/3}$, где m_1, m_2, m_3 — эфф. массы, соответствующие гл. осям эллипсоида. В случае вырожденной валентной зоны выражения для N_c и N_v имеют более сложный вид; однако если масса тяжёлых дырок гораздо больше массы лёгких дырок, то можно пользоваться ф-лами (11), заменив m^{\ddagger} массой тяжёлой дырки.

Концентрация электронов, находящихся на донорных уровнях, даётся выражением

$$n_d = N_d \left\{ 1 + g^{-1} \exp[-(\epsilon_d + \epsilon_F)/kT] \right\}^{-1}, \quad (12)$$

где g_d — кратность вырождения наименьшего донорного уровня (с учётом спинового вырождения); N_d — концентрация доноров; ϵ_d — энергия связи донора ($\epsilon_d > 0$). Концентрация дырок, захваченных на акцепторные уровни, т. е. концентрация нейтральных акцепторов, равна:

$$p_a = N_a \left\{ 1 + g^{-1} \exp[-(\epsilon_a - \epsilon_F - \epsilon_g)/kT] \right\}^{-1}. \quad (13)$$

Здесь g_a — кратность вырождения акцепторного уровня, N_a — концентрация акцепторов, ϵ_a — энергия связи акцептора ($\epsilon_a > 0$).

Уровень Ферми ϵ_F определяется из условия электростратности, согласно к-рому концентрация отриц. зарядов (электронов и заряд. доноров) должна быть равна концентрации положит. зарядов (дырок и нейтральных акцепторов):

$$n + N_a - p_a = p + N_d - n_d. \quad (14)$$

Для определения концентраций электронов n и дырок p следует подставить ф-лы (9) — (13) в (14), решить получающиеся ур-ние относительно ϵ_F , а затем, подставив ϵ_F в ф-лы (9) и (10), определить n и p . Из (9) и (10) видно, что произведение концентраций электронов n и дырок p не зависит от концентрации примесей:

$$n \cdot p = n_i^2 = N_c N_v \exp(-\epsilon_g/kT). \quad (15)$$

В случае стандартного спектра

$$p_i = n_i = \frac{(2\pi kT)^{3/2}}{4\pi^2 \hbar^3} (m^* m^{\ddagger})^{3/4} \exp(-\epsilon_g/2kT). \quad (16)$$

Собственные и примесные полупроводники. Собств. П. содержит электроны и дырки в одинаковом кол-ве: $n = p = n_i$. Эти электроны и дырки возникли, напр., за счёт теплового зарброса электронов из валентной зоны в зону проводимости. В собств. П. уровень Ферми находится примерно посредине запрещённой и определяется выражением

$$\epsilon_F = -\epsilon_g/2 + \frac{3}{4} kT \ln(n_i^2/m^* m^{\ddagger}). \quad (17)$$

При достаточно высокой тем-ре П. может быть собственным и при довольно больших концентрациях примесей. Для этого необходимо, чтобы концентрация n_i превысила N_d и N_a . Температурная область, в к-рой П. можно считать собственным, определяется шириной запрещённой зоны ϵ_g , концентрациями примесей, а также спектром электронов в дырок. В Ge $n_i = 2 \cdot 10^{13}$ см $^{-3}$, в Si $n_i = 1,5 \cdot 10^{10}$ см $^{-3}$ ($T = 300$ K).

П. наз. примесным, если N_d или N_a значительно превышают n_i . Гл. свойство примесного П. состоит в том, что концентрации электронов и дырок в нём резко отличаются друг от друга. П., в к-ром преобладают электроны (осн. носители заряда), наз. П. n -типа, а П., в к-ром преобладают дырки, — П. p -типа. В первом случае преобладают донорные примеси, во втором — акцепторные.

Если имеются только донорные примеси и тем-ра столь высока, что они все ионизованы, но в то же время достаточно низка, чтобы пренебречь тепловым зарбросом электронов из валентной зоны ($n_i < N_d$), то концентрация электронов $n \approx N_d$, а для ϵ_F справедлива ф-ла

$$\epsilon_F = kT \ln(N_d/N_c). \quad (18)$$

При $N_d < N_c$ уровень Ферми лежит несколько ниже «дна» зоны проводимости ϵ_c . Концентрация дырок в этом случае пренебрежительно мала по сравнению с концентрацией электронов. В случае акцепторных примесей существует аналогичный температурный интервал, в к-ром концентрация электронов пренебрежимо мала по сравнению с концентрацией дырок, а ϵ_F находится вблизи ϵ_v :

$$\epsilon_F = -\epsilon_g - kT \ln(N_a/N_v). \quad (19)$$

Если есть доноры и акцепторы, причём $N_d > N_a$, то каждый акцептор захватывает по электрону от доноров. Тогда при полной ионизации доноров концентрация электронов $n = N_d - N_a$. Аналогично при $N_a > N_d$ $p = N_a - N_d$. Т. о., примеси компенсируют друг друга. Поэтому П., в к-рых присутствуют и донорные и акцепторные примеси, наз. компенсированными; степенью компенсации K наз. отношение концентраций несвязанных (фоновых) и основных примесей, так что $0 \leq K \leq 1$.

При достаточно низких тем-рах в П. n -типа лишь малая часть электронов находится в зоне проводимости. Их концентрация зависит в этом случае от T экспоненциально:

$$n = \frac{1}{\sqrt{2}} (N_d N_c)^{1/2} \exp(\epsilon_d/2kT). \quad (20)$$

Выражение (20) справедливо лишь для слабо компенсированного П. При этом ϵ_F находится примерно посредине между донорным уровнем и ϵ_c :

$$\epsilon_F = -\frac{\epsilon_d}{2} + \frac{1}{2} kT \ln(N_d/2N_c). \quad (21)$$

Аналогичные выражения справедливы и для П. p -типа. В этом случае ϵ_F лежит между акцепторным уровнем

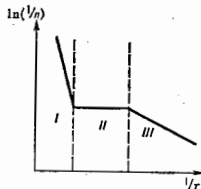
и ϵ_2 , а концентрация дырок экспоненциально зависит от T . В компенсации дырок n -типа при низких темп-рах ϵ_F практически совпадает с донорным уровнем, а зависимость $n(T)$ при $l \ll N_d$ имеет вид

$$n = N_c \frac{N_d - N_a}{2N_a} \exp(-\epsilon_d/kT). \quad (22)$$

На рис. 5 схематически показана зависимость $\ln(1/n)$ от $1/T$ в П. n -типа. Крутой участок (I) соответствует собств. П. Согласно (16), энергия активации, характеризующая угол наклона прямой в этой области, равна $\epsilon_d/2$. В области II все дырки изолированы и $n = N_d - N_a$. В самой низкотемпературной области (III) почти все электроны находятся на примесях и энергия активации, согласно (22), равна ϵ_d . В слабокомпенсирован. П., где $K < 1$, между областями III и II существует область, в к-рой, согласно (20), энергия активации равна $\epsilon_d/2$.

Т. о., концентрации подвижных электронов и дырок в П. экспоненциально уменьшаются с темп-рой, обращаясь в 0 при $T = 0$ K (рис. 5). Это явление наз. «вы-

Рис. 5. Зависимость логарифма концентрации электронов $\ln(1/n)$ от $1/T$ в полупроводнике n -типа.



мораживаемым» носителей. Оно объясняется локализацией носителей на примесях. Однако при достаточно большой концентрации примесей это свойство исчезает.

Сильнодегенирированные полупроводники. При достаточно высокой концентрации примесей существует остаточная концентрация подвижных электронов (или дырок), примерно равная концентрации примесей и слабо зависящая от T при низких темп-рах. Это приводит к появлению остаточной электропроводности металлич. типа, т. е. слабо зависящей от T . Напр.: в n -Si с примесью P остаточная электропроводность наблюдается при $N_d > 3.7 \cdot 10^{18}$ см $^{-3}$, в n -Ge с примесью Sb — при $N_d > 1.5 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$.

Переход к металлу. Электропроводности объясняется сближением соседних примесных уровней, вследствие чего образуется примесная энергетич. зона, к-рая, в конечном счёте, перекрывается с зоной проводимости. Критич. концентрация $N_{кр}$, при к-рой появляется электропроводность металлич. типа, как правило, описывается соотношением

$$N_{кр} a^3 \approx 0.02, \quad (23)$$

где a — радиус примесного состояния (расстояние, на к-ром волновая ф-ция примесного состояния падает в e раз), соответствующий данному сорту примесей в условиях слабого легирования. При концентрациях доноров N_d , удовлетворяющих неравенству $N_d a^3 \gg 1$, электронный газ при $T = 0$ K можно считать идеальным. Действительно, уровень Ферми находится в зоне проводимости и при стандартном спектре выражает зависимость

$$\epsilon_F = (3\pi^2)^{1/3} n^{1/3} / 2m, \quad (24)$$

причём в отсутствие компенсации ($N_a = 0$) $n = N_d$. При $N_d a^3 \gg 1$ энергия Ферми ϵ_F больше, чем энергия взаимодействия электронов с примесями и друг с другом. Поэтому электронный газ можно считать идеальным.

Т. о., статистика электронов в сильнодегенир. П. такая же, как в металлах, хотя концентрация носите-

лей значительно ниже металлической. При достаточно высоких T ($kT \gg \epsilon_F$) фермиевское вырождение электронного газа исчезает, электронный газ становится максвелловским, а ϵ_F определяется ф-лой (18).

Если в П. n -типа имеются такие акцепторы, то в ф-лу (24) следует подставить $n = N_d - N_a$. При точной компенсации, когда N_d и N_a достаточно близки, электронный газ не является идеальным. Электроны находятся в поле со случайным потенциалом, создаваемым донорами и акцепторами. Случайный потенциал можно рассматривать как искривление «дна» зоны проводимости ϵ_c . При очень точной компенсации характерная амплитуда случайного потенциала становится больше, чем ϵ_F , определяемая ф-лой (24). При этом электроны находятся лишь в самых глубоких местах потен. рельефа, образуя изолированные друг от друга k и l (рис. 6). При $T = 0$ K такая система становится диэлектриком. Электропроводность осуществляется путём теплового заброса электронов на т. н. уровень протекания (см. Протекающая теория).

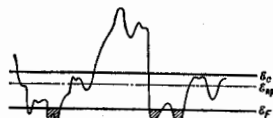


Рис. 6. Энергетическая схема компенсированного полупроводника. Иволнистая линия изображает искривление «дна» зоны проводимости, верхняя сплошная линия — энергию «дна» зоны проводимости в отсутствие примесного потенциала, нижняя сплошная линия — уровень Ферми, штрих-пунктирная линия — уровень протекания. Заштрихованы области, занятые электронами (электронные капли).

Процессы переноса

Электропроводность. Носителями заряда в П., помимо электронов, могут быть и дыры, однако важная электропроводность в типичных П. пренебрежительно мала (исключение — ионные суперпроводники). В П. осуществляются 3 гл. механизма электронного переноса: основной зонный перенос (движение электрона связано с изменением его энергии в пределах одной, разрешённой энергетич. зоны); прыжковый перенос по локализов. состояниям (см. Прыжковая проводимость); поляронный перенос (см. Полярон).

Электропроводность П. меняется в очень широких пределах при изменении темп-ры и концентрации примесей. Изменение происходит как за счёт изменения концентрации подвижных носителей n , так и за счёт изменения характера их рассеяния. Электропроводность σ можно представить в виде

$$\sigma = en\mu, \quad (25)$$

где μ — подвижность носителя заряда, к-рая в невырожденном П. не зависит (или зависит слабо) от n . Подвижность определяется отношением дрейфовой скорости v_D носителей под действием электрич. поля к напряжённости поля E :

$$\mu = v_D/E. \quad (26)$$

Существуют прямые методы измерения подвижности, основанные на соотношении (26), но чаще всего подвижность определяют по величине μ и коэф. Холла R_H , измеренному в слабом магн. поле H (см. Холла эффект):

$$\mu = R_H \sigma. \quad (27)$$

Подвижность, определённую таким способом, часто наз. холловской. Она может отличаться от подвижности, определяемой ф-лой (26).

Величина μ и её температурная зависимость определяются состоянием носителя (зонное, примесное, по-

лярное) и механизмом их рассеяния. Для зонной электропроводности П. характерны высокие значения μ . Так, в слаболегированном n-Ge при $T = 77$ К $\mu = 10^4$ см²/(В·с). Если $\mu < 1$ см²/(В·с), то обычно это означает, что механизм электропроводности поларонный или прыжковый.

Электрон, энергия которого лежит в разрешённой зоне в идеальной кристаллич. решётке, может двигаться без рассеяния, сохраняя свой квазиимпульс. Рассеяние вызывается отклонениями от идеальной периодич. структуры, связанными с тепловыми колебаниями атомов (рассеяние на фононах), примесями и дефектами структуры. Кроме того, носители могут рассеиваться друг на друге (см. *Рассеяние носителей заряда*).

Наиб. важные механизмы, определяющие подвижность носителей в области $T < 300$ К, — рассеяние на акустич. фононах и заряд. примесях. В невырожденных П. при рассеянии на акустич. фононах $\mu \sim T^{-1/2}$, а при рассеянии на заряд. примесях $\mu \sim T^{3/2}$. При более высоких темп-рах преобладает первый механизм, а при более низких — второй, вследствие чего зависимость $\mu(T)$ имеет характерный максимум. Если энергия теплового движения носителей (kT) сравнима или превышает энергию оптич. фонона, то важную роль играет рассеяние на оптич. фононах. В твёрдых растворах важно рассеяние на флуктуирующ. составе, при к-ром $\mu \sim T^{-1/2}$.

В сильнолегиров. П. при низких темп-рах основным является рассеяние на заряд. примесях, экранированных электронами проводимости. В этом случае и подвижность μ , и электропроводность σ слабо зависят от T и можно говорить об электропроводности $\sigma(0)$, представляющей результат экранирования ф-ции $\sigma(T)$ к $T = 0$ К. При концентрации примесей, меньшей чем $N_{кр}$, вианотемпературная электропроводность носит активацион. характер, т. к. концентрация подвижных носителей экспоненциально падает с понижением темп-ры. При $N > N_{кр}$ $\sigma(0) \neq 0$. Это означает, что электроны локализованы на примесях. При вязкой концентрации примесей центрами локализации являются отл. примеси, а при концентрации, приближающейся к $N_{кр}$, область локализации электрона включает много примесных центров. Согласно теории, представленной в величине $\sigma(0)$ как ф-ция концентрации примесей N обращается в 0 при $N \rightarrow N_{кр}$ в соответствии со степенным законом

$$\sigma(0) \sim (N - N_{кр})^t, \quad (28)$$

где $t > 0$ — нек-рое число, называемое критическим индексом. Переход от электропроводности металл. типа к электропроводности активационной наз. переходом Мотта — Андерсона (см. *Переход металл — диэлектрик*).

Электропроводность в сильном электрич. поле. Отклонения от закона Ома в сильном электрич. поле в П. связано гл. обр. с разогревом газа носителей. Энергия, получаемая носителями от электрич. поля, передается при столкновениях фононам и приводит к выделению джоулевой теплоты. Однако мощность, получаемая от поля, может быть столь велика, что носители не успевают передать её фононам, вследствие чего их темп-ра оказывается выше, чем темп-ра решётки. В этом случае говорят о горячих носителях (см. *Горячие электроны*). Разогрев возникает, если кол-во энергии, получаемое носителем от поля за время между столкновениями, превышает энергию, передаваемую фонону при одном столкновении.

Если темп-ра носителей зависит от электрич. поля, то закон Ома не выполняется, в вид вольт-амперных характеристик П. (ВАХ) определяется мн. факторами. Разогретые носители могут, напр., оказаться в др. области энергетич. спектра и при этом резко изменить свою подвижность. Это может привести к неустойчивости; примером к-рой является *Ганна эффект* (см. также *Паажа теорема*). Др. видом неустойчиво-

сти является лавинный пробой. Электроны в электрич. поле приобретают кинетич. энергию, сравнимую с шириной запрещённой зоны E_g , и при этом выбивают электроны из валентной зоны в зону проводимости. Эти электроны в свою очередь разгоняются полем и выбивают новые электроны и т. д. Специфическим для П. является т. н. пргмесный пробой, возникающий в значительно более слабом поле. В этом случае электроны выбиваются не из валентной зоны, а с примесных уровней.

Гальваномагнитные явления в П. позволяют экспериментально исследовать параметры зонной структуры и примесный состав. Простейшим методом определения знака заряда носителей и их концентрации является измерение постоянного Холла R_H в слабом магн. поле. При одном сорте носителей

$$R_H = r/een, \quad (29)$$

где r — коэф., зависящий от механизма рассеяния носителя. Если носителями являются одновременно и электроны и дырки, причём их взаимодействием можно пренебречь, то электропроводность можно представить в виде суммы

$$\sigma = e\mu_3 n_3 + e\mu_4 n_4, \quad (30)$$

где μ_3 , μ_4 — подвижности электронов и дырок. Коэф. Холла в этом случае связан с μ_3 и μ_4 соотношением

$$R_H = e^2 (\mu_3^2 n_3 - \mu_4^2 n_4) / \sigma^2. \quad (31)$$

Как видно из ф-лы (31), знак R_H в П. n - и p -типов разный.

Более точно концентрацию носителей можно определить, измеряя эффект Холла в сильном магн. поле, когда *циклотронная частота* носителей велика по сравнению с частотой столкновения и для электронов и для дырок. Тогда

$$R_H = 1/e(p - n). \quad (32)$$

Особую роль играет т. н. *квантовый Холла эффект*. Он возникает в двумерной системе, к-рая реализуется, напр., в инверсионном слое МДП-структуры. Если сильное магн. поле направлено перпендикулярно слою, то зависимость холловской электропроводности σ_H от магн. поля содержит «ступеньки», к-рые описываются ф-лой

$$\sigma(H) = \nu e^2 / h, \quad (33)$$

где величина ν принимает нек-рые целые и дробные значения. Точность, с к-рой выполняется соотношение (33), столь высока, что квантовый эффект Холла с успехом может служить методом измерения соотношения мировых констант.

Важную роль для определения параметров П. играют также измерения отрицат. магнетосопротивления в слабом магн. поле. Магн. поле разрушает квантовую интерференцию электронных состояний и этим увеличивает электропроводность системы (см. *Магнетосопротивление. Слабая локализация*).

Термоэлектрич. эффекты в П. важны и как средство определения параметров П. и для практич. приложений. *Термоэдс* у П. значительно больше по величине, чем у металлов. Термоэдс вырожденного электронного газа порядка $(k/e) \cdot (kT/e\mu)$, причём у типичных металлов множитель $kT/e\mu$ очень мал. Термоэдс невырожденных П. такого множителя не содержит, и потому она значительно больше. В связи с этим П. используются для создания термоэлементов. Для исследования П. важную роль играет измерение термоэлектрич. эффектов в магн. поле.

Оптические свойства полупроводников

Прямые и непрямые переходы. Фундаментальное или собственное поглощение света в П. связано с переходом электронов из валентной зоны в к.-л. незаполненную

зону. Эти переходы могут быть прямыми и непрямыми. В прямых переходах участвуют лишь электрон и фотон. Законы сохранения энергии и импульса при прямых переходах имеют вид

$$\begin{aligned} \hbar\omega &= \mathcal{E}_c(p) - \mathcal{E}_v(p); \\ p' - p &= \hbar q. \end{aligned} \quad (35)$$

Здесь p и p' — квазиимпульсы электрона в начальном и конечном состояниях, $\hbar\omega$ — энергия фотона, q — его волновой вектор. Т. к. импульс фотона $\hbar q$ мал по сравнению с p' и p , то $p \approx p'$ (рис. 7). Если экстремумы обеих зон находятся в одной точке импульсного пространства, порог прямых переходов (край поглощения) совпадает с \mathcal{E}_g . Фотона с $\hbar\omega < \mathcal{E}_g$ могут поглощаться лишь за счёт значительно менее вероятных процессов (см. ниже); прозрачность П. резко возрастает при $\hbar\omega < \mathcal{E}_g$.

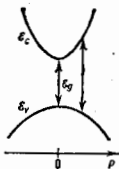


Рис. 7. Прямые переходы; экстремумы зон проводимости и валентной зоны находятся в точке $p = 0$.

Непрямыми наз. переходы, в к-рых кроме электрона и фотона участвует фонон или примесный центр. В этом случае соотношение $p \approx p'$ не выполняется. Непрямые переходы менее вероятны, однако они определяют коэф. поглощения света при $\hbar\omega > \mathcal{E}_g$ в случае, когда экстремумы зон находятся в разных точках импульсного пространства. У Ge, напр., абс. экстремум зоны проводимости находится в точке В (рис. 8), к-рая лежит на границе зоны Бриллюэна. Максимум валентной зоны лежит в точке А при $p = 0$. Зона проводимости имеет более высокий минимум в точке С при $p = 0$. Разность энергий между точками С и А равна \mathcal{E}_{cv} . Прямые переходы возможны лишь при $\hbar\omega > \mathcal{E}_{cv}$. В области энергий $\mathcal{E}_g \leq \hbar\omega < \mathcal{E}_{cv}$ возможны лишь не прямые переходы (наклонная линия). Коэф. поглощения света вблизи фундам. края $\sim 10^4 - 10^6 \text{ см}^{-1}$ при прямых переходах и $\sim 10^3 \text{ см}^{-1}$ при не прямых переходах.

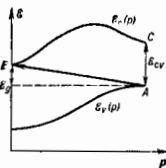


Рис. 8. Прямые и не прямые переходы для зонной структуры Ge.

Экситон. Структура края фундам. поглощения усложняется за счёт взаимодействия электрона в зоне проводимости в дырки в валентной зоне, возникающих при поглощении фотона. Электрон и дырка могут образовывать связанное состояние, к-рое наз. *Ванье — Мотта экситоном*. Вследствие этого энергия фотона, соответствующая краю поглощения, уменьшается на величину энергии связи экситона. Т. к. экситон имеет также возбуждённые состояния, то край фундам. поглощения имеет структуру, напоминающую бальмеровскую серию атома водорода. При достаточной большой интенсивности света в П. может образоваться значит. кол-во экситонов. С увеличением их концентрации они

конденсируются, образуя *электронно-дырочную жидкость*.

Влияние внешних полей. Структура края фундам. поглощения изменяется под влиянием электрич. и магн. полей. Электрич. поле «наклоняет» зоны и делает возможным туннельный переход при $\hbar\omega < \mathcal{E}_g$ (см. Квантовая — Франца эффект). Магн. поле вызывает эквивалентное энергия электронов и дырок, т. е. возникоение эквивалентных *Ландау уровней*, расстояния между к-рыми равно $\hbar e H / m$, где m — эфф. масса электрона или дырки. Плотность состояний носителя заряда вблизи уровней Ландау возрастает, вследствие чего появляются осциллирующ. коэф. поглощения как ф-ция частоты света. Максимум поглощения соответствует переходам между уровнями Ландау. Изучение осцилляций позволяет расшифровать спектр электронов и дырок (см. *Квантовые осцилляции в магнитном поле*).

Размерное квантование. На край фундам. поглощения влияет также т. н. размерное квантование, к-рое возникает, если образец представляет собой тонкую плёнку или имеет маленькие размеры во всех измерениях. Соответствующие уровни энергии также проявляются при межзонаном поглощении (см. *Квантовые размерные эффекты*).

При $\hbar\omega < \mathcal{E}_g$ важную роль играет внутрizonное поглощение. Квантование в магн. поле или размерное квантование может значительно усилить внутрizonное поглощение на выделенных этим квантованием частотах, что также позволяет изучать спектр носителей. *Циклотронный резонанс* оказался наиб. важным явлением такого рода: электроны в сильном пост. магн. поле H движутся по замкнутым траекториям, причём период обращения зависит от вида энергетич. спектра П., от величины магн. поля H и его направления относительно кристаллографич. осей. Образец помещают в ВЧ-поле и исследуют поглощение энергии этого поля в зависимости от величины H . Резонанс возникает, когда частота поля совпадает с циклотронной частотой электрона.

Генерация неравновесных носителей. Концентрация равновесных электронов и дырок определяется теми-рой образом. Мп. важные свойства П. связаны с неравновесными состояниями, к-рые могут быть созданы разными способами, напр. при возбуждении светом и инжекцией через контакты. При облучении светом, с $\hbar\omega > \mathcal{E}_g$ генерируются электроны и дырки, к-рые являются неравновесными. При стационарном освещении их концентрация не зависит от времени и определяется интенсивностью света и временем жизни носителей (в свободном состоянии). Они обуславливают явление *фотопроводимости* — изменения электропроводности под действием света. Иногда электропроводность при освещении отличается на много порядков от т. н. темновой электропроводности. Если прекратить освещение, концентрация носителей возвращается к равновесному значению за время порядка времени жизни неравновесных носителей. Малая инерционность этого явления позволила создать чувствит. приборы для регистрации светового излучения, в т. ч. и для ИК-диапазона (см. *Приёмники оптического излучения*).

При протекании тока через контакт П. с металлом или др. П. неравновесные электроны и дырки заполняют приконтактную область, причём их концентрация зависит от величины тока, а толщина области, заполненной неравновесными носителями, — от длины, на к-рую они диффундируют за время жизни (см. *Инжекция носителей заряда, Контактные явления в полупроводниках*).

Рекombинация. Время жизни носителей определяется рекомбинац. процессами, в результате к-рых исчезают электронно-дырочные пары, т. е. электроны возвращаются из зоны проводимости в валентную зону. Рекомбинация неравновесных носителей может сопровождаться излучением квантов света (*люминесценция*).

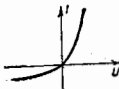
Люминесценция может быть вызвана светом (фотолюминесценция) или электрич. током (электрoлюминесценция). На явления электрoлюминесценции основана работа большинства полупроводниковых излучателей света (см. Светоизлучающий диод. Рекомбинация носителей заряда в полупроводниках).

За счёт неравновесных носителей в П. может возникать и инверсия и населённость в т. н. активной области электронов на более высоких уровнях энергии число, чем на виаках. В таких условиях излучение света превышает его поглощение, т. е. происходит усиление света. Усиление происходит лишь в т. н. активной области П. В остальных местах инверсия населённости отсутствует и преобладает поглощение света. Если усиление света в активной области столь велико, что оно компенсирует и потери в пассивной области и выход световой энергии вовне, то возникает генерация света. В полупроводниковых лазерах инверсия населённости обычно достигается инжекцией неравновесных носителей через контакты (см. Инжекционный лазер, Гетеролазер).

При безызлучат. рекомбинации выделяемая энергия в конечном счёте отдаётся решётке. Механизмы безызлучат. рекомбинации разнообразны. При небольших концентрациях носителей осн. механизмом является рекомбинация через промежуточное состояние в запрещённой зоне, образованное примесью или дефектом решётки. Примесь захватывает сначала носитель одного знака (напр., электрон), а затем второго знака (дырку). В результате электрон и дырка исчезают, а примесь или дефект возвращается в исходное зарядовое состояние. Аналогичным механизмом является поверхностная рекомбинация, к-рая происходит при участии поверхностных состояний. При больших концентрациях носителей важную роль играет т. н. оже-рекомбинация, когда энергия передаётся 3-му носителю. Оже-рекомбинация обусловлена взаимодействием электронов. При конструировании светодиодов и лазеров безызлучат. рекомбинация нежелательна и её стараются по возможности уменьшить.

Полупроводниковые структуры. Простейшей полупроводниковой структурой является $p-n$ -переход. Его получают, легируя образец так, чтобы в одной его части преобладали донорные, в другой — акцепторные примеси. Осн. свойство $p-n$ -перехода состоит в том, что абс. величина тока I , к-рый течёт через него, сильно зависит от полярности приложенного напряжения U (рис. 9). Если переход включён в прямом направлении,

Рис. 9. Вольт-амперная характеристика $p-n$ -перехода.



то электроны и дырки движутся по направлению к границе областей и рекомбинируют вблизи неё. Этот механизм обеспечивает относительно большой ток. Если переход включён в обратном направлении, то носители движутся от границы. В этом случае ток течёт лишь за счёт генерации электронно-дырочных пар вблизи границы и оказывается по величине значительно меньше, чем ток в прямом направлении. Т. о., $p-n$ -переход может работать как выпрямитель. На основе $p-n$ -переходов делают также солнечные батареи, светодиоды, лазеры и др. приборы (см. Диоды твердотельные). Два $p-n$ -перехода, включённые навстречу друг другу, образуют транзистор.

Для нужд полупроводниковой электроники изготавливают т. н. pn -диоды, в к-рых p - и n -области разделены областью с собствен. проводимостью (i), а также периодич. структуры, состоящие из большого кол-ва p - и n -областей ($p-n-p$ и др.). Все перечисленные выше структуры получают путём легирования дозорами

и акцепторами к-л. одного материала (см. Легирование полупроводников). Гетероструктуры и гетеропереходы, представляющие собой контакт разных полупроводниковых материалов, применяются при создании полупроводниковых лазеров и др. полупроводниковых приборов.

Метод молекулярной эпитаксии позволяет создать сверхструктуры, представляющие собой периодич. чередование П. с разными ρ (рис. 10). При этом в зоне проводимости и в валентной зоне возникают периодически расположенные потенц. ямы и барьеры, размеры к-рых могут быть порядка неск. межатомных расстояний. В результате в зоне проводимости и в валентной зоне появляются т. н. мини-зоны, раз-

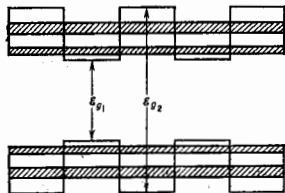


Рис. 10. Энергетическая схема сверхструктуры (мини-зонная структура).

делённые запрещёнными интервалами энергии. Благодаря этому сверхструктуры обладают свойствами, нашедшими применение в твердотельной электронике.

Поверхность полупроводника. Под поверхностью П. понимают неск. атомных слоев вблизи границы П. Она обладает свойствами, отличающимися от объёмных. Наличие поверхности нарушает трансляц. симметрию кристалла и приводит к *поверхностным состояниям* для электронов, а также к особым ал.-магн. волнам (поверхностные плазмоны), колебл. и спиновым волнам. Благодаря своей хим. активности поверхность, как правило, покрыта макроскопич. слоем сторонних атомов или молекул, адсорбируемых из окружающей среды. Эти атомы и определяют физ. свойства поверхности, маскируют состояния, присущие чистой поверхности. Развитие техники сверхвысокого вакуума позволило получать и сохранять в течение неск. часов атомарно чистую поверхность. Исследования чистой поверхности методом дифракции медленных электронов показали, что кристаллографич. плоскости могут смещаться как целое в направлении, перпендикулярном к поверхности. В зависимости от ориентации поверхности по отношению к кристаллографич. осям это смещение может быть направлено внутрь П. или наружу. Кроме того, атомы приповерхностного слоя изменяют положение равновесия в плоскости, перпендикулярной поверхности, по сравнению с их положениями в такой же плоскости, находящейся далеко от поверхности (*реконструкция поверхности*). При этом возникает упорядоченная двумерная структура с симметрией влже объёмной или не полностью упорядоченные структуры. Первые являются термодинамически равновесными, в их симметрия зависит от ориентации поверхности. При изменении темп-ры могут происходить фазовые переходы, при к-рых симметрия структуры изменяется (см. Поверхности).

Лит.: А н с е л ь м. А. К., Введение в теорию полупроводников, 2 изд., М., 1978; С м и т Р., Полупроводники, пер. с англ., 2 изд., М., 1982; Б о н ч - Б р у е в и ч В. Л., К а т л а ш а н и к о в С. Г., Физика полупроводников, М., 1977, А. Л. Збуров.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ — вещества с чётко выраженными свойствами полупроводников в широком интервале темп-р, включая комнатную ($T \sim 300$ К). Характеризуются значеванным уд. электрoпроводностью ($\sigma \sim 10^4 - 10^{10}$ Ом \cdot см $^{-1}$ при

$T \sim 300$ К), промежуточными между уд. электропроводностью металлов и хороших диэлектриков. В отличие от металлов, концентрация подвижных носителей заряда в П. м. значительно ниже концентрации атомов, а электропроводность σ возрастает с ростом T . Для П. м. характерна высокая чувствительность эл.-физ. свойств к внеш. воздействию (нагрев, облучение, деформация и т. д.), а также к содержанию примесей и структурных дефектов. Характеристики важнейших П. м. приведены в табл. 1.

По структуре П. м. делятся на кристаллические, аморфные, жидкие. Ряд органич. веществ также проявляет полупроводниковые свойства и составляет обширную группу органических полупроводников. Наиб. значение имеют неорганич. кристаллич. П. м., к-рые по хим. составу разделяются на элементарные, двойные, тройные и четверные хим. соединения, растворы и сплавы. Полупроводниковые соединения классифицируются по номерам групп периодич. табл. элементов, к к-рым принадлежат входящие в их состав элементы.

Основные группы кристаллических полупроводниковых материалов (см. табл. 1):

1. Элементарные П. м.: Ge, Si (алмаз), В, α -Sn, Te, Se и др. Важнейшими представителями этой группы являются Ge и Si — осн. материалы полупроводниковой электроники. Обладая 4 валентными электронами, атомы Ge и Si образуют кристаллич. решётку типа алмаза, где каждый атом имеет 4 ближайших соседа, с каждым из к-рых связан ковалентной связью (координация соседей — тетраэдрическая). Они образуют между собой непрерывный ряд *твёрдых растворов*, также являющихся важными П. м.

2. Соединения типа $A^{III}B^V$. Имеют в осн. кристаллич. структуру типа сфалерита. Связь атомов в кристаллич. решётке носит преим. ковалентный характер с нек-рой долей (5—15%) ионной составляющей (см. *Химическая связь*). Важнейшие представители этой группы: GaAs, InP, InAs, InSb, GaP. Мн. П. м. $A^{III}B^V$

образуют между собой непрерывный ряд твёрдых растворов тройных и более сложных ($Ga_xAl_{1-x}As$, $GaAs_xP_{1-x}$, $Ga_xIn_{1-x}P$, $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ и т. д.), к-рые также являются важными П. м. (см. *Температурный переход. Температурная*).

3. Соединения элементов VI группы (O, S, Se, Te) с элементами I—V групп, а также с переходными и редкоземельными металлами. Среди этих П. м. наиб. интерес представляют соединения типа $A^{IV}B^VI$. Они имеют кристаллич. структуру типа сфалерита или вюрцита, реже — типа NaCl. Связь между атомами носит ковалентно-ионный характер (доля ионной составляющей порядка 45—60%). Для П. м. типа $A^{IV}B^VI$ характерны явления *полиморфизма* и наличие поли типов кубической и гексагональной модификаций. Важнейшие представители: CdTe, CdS, ZnTe, ZnSe, ZnO, ZnS. Мн. П. м. типа $A^{IV}B^VI$ образуют между собой непрерывный ряд твёрдых растворов; важнейшие из них: $Cd_xHg_{1-x}Te$, $Cd_xHg_{1-x}Se$, $CdTe_xSe_{1-x}$. Физ. свойств в значит. мере определяются концентрацией собственных точечных дефектов структуры, проявляющих электр. активность (центры рассеяния и рекомбинации).

Соединения типа $A^{IV}B^VI$ имеют кристаллич. структуру типа NaCl или орторомбическую. Связь между атомами — ковалентно-ионная. Типичные представители: PbS, PbTe, SnTe. Они образуют между собой непрерывный ряд твёрдых растворов, среди них наиб. важны $Pb_xSn_{1-x}Te$, $Pb_xSn_{1-x}Se$. Собств. точечные дефекты структуры в $A^{IV}B^VI$ имеют низкую энергию ионизации и проявляют электр. активность.

Соединения типа $A^{II}B^VI$ имеют кристаллич. структуру типа сфалерита с $1/2$ незаполненных катионных узлов. По своим свойствам занимают промежуточное положение между $A^{III}B^V$ и $A^{IV}B^VI$. Для них характерны низкие решетчатая теплопроводность и *подвижность носителей заряда*. Типичные представители: Ga_2Te_3 , Ga_2Se_3 , In_2Te_3 .

Табл. 1. — Характеристики важнейших полупроводниковых материалов (* означает усреднение по кристаллографическим направлениям)

Полупроводниковый материал	Тип кристаллич. решётки	Период кристаллич. решётки, A (300 К)	$T_{пл}$, °C	Плотность, г/см ³ (300 К)	Коеф. линейного расширения $\times 10^{-6}$, K ⁻¹	Коеф. теплопроводности, Вт \times см ⁻¹ \times град ⁻¹	Диэлектрич. проницаемость, ϵ_0^*	Темп-ра Дебая, θ_D
Si	кубическая (алмаз)	5,43072	1417	2,32830	2,4(300 К)	1,3	11,7	680(300 К) 539(80 К)
Ge	—	5,65754	937	5,32600	5,75(300 К)	0,63	16	490(300 К) 353(80 К)
$A^{III}B^V$								
InSb	кубическая (сфалерит)	6,4795	525	5,775	5,04(300 К)	0,17	17,5	202(300 К)
InAs	—	6,05838	943	5,667	5,19(300 К)	0,27	14,5	249(300 К)
InP	—	5,86875	1062	4,787	4,73(300 К)	0,67	14	321(300 К)
GaSb	—	6,09866	706	5,1220	6,7(298—873 К)	0,34	15	263(300 К)
GaAs	—	5,6535	1238	5,3161	6,0(300 К)	0,16	12,5	344(300 К)
GaP	—	5,4495	1470	4,1297	5,3(300 К)	0,75	10,2	446(300 К)
$A^{IV}B^VI$								
ZnS	кубическая (сфалерит) гексагональная (вюрцит)	5,4093 $a=3,820$ $c=6,250$	1830	4,09	6,14(300 К)	0,026	8,16*	310(300 К) 315(80 К)
ZnSe	кубическая (сфалерит) гексагональная (вюрцит)	5,8687 $a=4,093$ $c=7,090$	1427	5,264	9,44(300—1000 К)	0,19	8,5*	400(80 К)
ZnTe	кубическая (сфалерит) гексагональная (вюрцит)	$a=6,1033$ $kI=6,4, 310$ $kII=6,4, 090$ $c=7,090$	1239	5,633	9,02(300 К)	0,18	9,8*	250(80 К)
CdS	кубическая (сфалерит)	5,820	1740	4,825	6,5(300—1100 К)	0,2	9,3*	250—300(300 К)
CdSe	гексагональная (вюрцит) кубическая (сфалерит)	$a=4,1368$ $c=6,7136$ 0,6050	1347	5,81	—	0,043	9,5*	230(80 К)
CdTe	гексагональная (вюрцит) кубическая (сфалерит)	$a=4,304$ $c=7,018$ 6,482	1092	5,85	4,9(300 К)	0,075	10,5*	200(80 К)
HgTe	кубическая (сфалерит)	5,463	670	6,076	4,0(300 К)	0,016	48*	—

Табл. 2. — Параметры зонной структуры и свойства носителей заряда для важнейших полупроводниковых материалов

Полупроводниковый материал	Тип зонной структуры	ϵ_0 , эВ (300 К)	$\partial\epsilon_0/\partial T, \cdot 10^{-4}$, эВ/град $^{\circ}$	$\partial\epsilon_0/\partial p, \cdot 10^{-4}$, эВ/бар	m в долях m_0 (300 К)		μ , см 2 ·В $^{-1}$ ·с $^{-1}$	
					электроны	дырки	электроны	дырки
Si	непрямозонный	1,14	-4	1,5	0,33	0,55	1500(300K)	480(300K)
Ge	—	0,67	-4	5	0,22	0,39	4500—	1900—
$A^{III}B^V$								
InSb	прямозонный	0,18	-2,8	14,8(000)	0,013	0,4	8000—	750—
InAs	—	0,356	-2,2	8,5(000)	0,025	0,4	1,2·10 4 (77K)	9,1·10 3 (77K)
InP	—	1,35	-2,9	4,6	0,073	0,4	3500(300K)	240(300K)
GaSb	—	0,79	-3,8	12	0,042	0,5	5000—	200—
GaAs	—	1,43	-3	12,5	0,072	0,68	4000—	1400—
GaP	непрямозонный	2,26	-5,5	1,7	0,35	0,5	8500—	450—
							300—	100—
$A^{II}B^{VI}$								
ZnS	прямозонный	3,68	-5,3	5,7	0,23	0,6	170	—
ZnSe	—	2,8	-7,2(30—400K)	6	0,16	0,6	260(300K)	15—
ZnTe	—	2,25	—	6	0,17	0,8	340—	110—
CdS	—	2,42; 2,53	-4,4(77—300K)	3,3	0,2	0,5	350—	50—
CdSe	—	1,85	-4,6(30—400K)	3,0	0,13	0,6	550—	30—
GdTe	—	1,55	-4,1(77—394K)	3,0	0,11	0,35	4·10 4 (77K)	100—
							1200(300K)	80—
HgTe	—	0,15	-16(4K)	10	0,017	0,16	2,3·10 4 —	100—
					0,03(1,2K)	0,35	7·10 4 (77K)	—

4. Тройные соединения типа $A^{III}B^{IV}C^V$. Кристаллизуются в осн. в решетке халькопирита. Обнаруживают упорядочение в магн. и электрич. полях. Образуют между собой твердые растворы. Типичные представители: CdSnAs $_2$, CdGeAs $_2$, ZnSnAs $_2$.

5. Карбид кремния SiC — единств. соедине-ние, образуемое элементами IV группы между собой; существует в неск. структурных модификациях; α -SiC (структура сфалерита), β -SiC (гексагональная структура), имеющая ок. 15 разновидностей.

Некристаллические полупроводниковые материалы

Типичными представителями являются стеклообразные П. м. — халькогениды и оксиды. К первым относятся элементы TI, P, As, Sb, Bi с S, Se, Te, характеризующиеся широким диапазоном значений σ , низким темп-рами размягчения, устойчивостью к кислотам и щелочам. Типичные представители: As $_2$ Se $_3$ — As $_2$ Te $_3$, TI $_2$ Se — As $_2$ Se $_3$. Оксидные стеклообразные П. м. имеют состав типа V $_2$ O $_5$ — P $_2$ O $_5$ — RO $_2$ (R — металлы I — IV групп); $\sigma = 10^{-10}$ — 10^{-3} Ом $^{-1}$ ·см $^{-1}$. Стеклообразные П. м. имеют электронную проводимость, обнаруживают фотопроводимость в термоэдс. При медленном охлаждении обычно превращаются в кристаллич. П. м.

Важными некристаллич. П. м. являются также твердые растворы водорода в аморфных полупроводниках (гидрированные некристаллич. П. м.): α -Si(H), α -Si $_x$ -C $_x$ (H), α -Si $_x$ -Ge $_x$ (H), α -Si $_x$ -N $_x$ (H), α -Si $_x$ -S $_x$ (H). Водород обладает высокой растворимостью в этих П. м. и замыкает на себя значит. кол-во «болтающихся» связей, характерных для аморфных П. м. В результате резко снижается плотность состояний носителей заряда в запрещенной зоне и появляется возможность создания p — n переходов (см. Аморфные и стеклообразные полупроводники).

Свойства полупроводниковых материалов

Осн. физ.-хим. свойства важнейших П. м. представлены в табл. 1 и 2.

Прслеживаются следующие общие закономерности в изменении свойств. С увеличением энергии связи между атомами уменьшается период кристаллич. решетки a , возрастает темп-ра плавления $T_{пл}$ и ширина запрещенной зоны E_g . С увеличением молекулярной (атомной) массы период кристаллич. решетки a возрастает,

$T_{пл}$ и E_g уменьшаются. Нагрев П. м. приводит к увеличению a ; внеш. давление p вызывает уменьшение a . При этом соотв. уменьшаются или увеличиваются энергия связи между атомами и ширина запрещенной зоны E_g (табл. 1).

Зонная структура. В большинстве практически важных П. м. валентные зоны имеют сходное строение. Они вырождены и состоят из зоны тяжелых дырок v_1 , зоны легких дырок v_2 и спиноразделенной зоны v_3 (рис. 1). Все зоны имеют максимум в центре Бриллю-

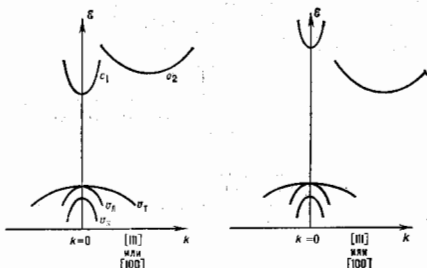


Рис. 1. Зонная структура: слева — прямозонных полупроводниковых материалов; справа — непрямозонных.

нова зоны ($k = 0$). Перенос носителей в П. м. с дырочной проводимостью определяется дырками первых 2 зон, эфф. массы k -рых приведены в табл. 2 (см. Зонная теория).

В зоне проводимости, помимо минимума в центре Бриллюнова зоны ($k = 0$), есть побочные минимумы, располагающиеся вдоль кристаллографич. направлений [100] или [111]. Электроны в центр. минимуме c_1 имеют высокую подвижность и малую эфф. массу m , в побочных минимумах — низкую подвижность и большую m . Если энергетически наиб. низкий является минимум в центре Бриллюнова зоны, то такие П. м. наз. «прямозонными». П. м., где энергетически наиб. низкими являются минимумы в направлениях

[100] или [111], относятся к числу «непрямозонных». В прямозонных П. м. электроны проводимости имеют высокую подвижность и малую эфф. массу, в непрямозонных наоборот (табл. 2). Величина коэф. поглощения света вблизи края фундаментального поглощения

Табл. 3. — Коэффициент излучательной рекомбинации $K_{\text{и}}$

Полупроводниковый материал	Тип зонной структуры	$K_{\text{и}}, \text{см}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$
Si	Непрямозонный	$1,79 \cdot 10^{-14}$
Ge	—	$5,25 \cdot 10^{-14}$
GaP	—	$5,37 \cdot 10^{-14}$
GaAs	Прямозонный	$7,21 \cdot 10^{-10}$
GaSb	—	$2,39 \cdot 10^{-10}$
InAs	—	$8,5 \cdot 10^{-11}$
InSb	—	$4,58 \cdot 10^{-11}$

в прямозонных П. м. $10^4 - 10^5 \text{ см}^{-1}$, в непрямозонных П. м. — $10^3 - 10^4 \text{ см}^{-1}$. Прямозонные П. м. обнаруживают более высокой коэф. излучат. рекомбинации (табл. 3) (см. Рекомбинация носителей заряда).

Свойства полупроводниковых твёрдых растворов зависят от их состава и природы составляющих компонентов. Период кристаллич. решётки обычно линейно зависит от концентрации растворённого компонента (нравило Вегарда). Концентрац. зависимость подвижности носителей μ , времени их жизни τ , интенсивности излучат. рекомбинации $K_{\text{и}}$ и оптич. поглощения в твёрдых растворах прямозонных П. м. описываются плавными кривыми между значениями, характерными для составляющих их компонентов (рис. 2).

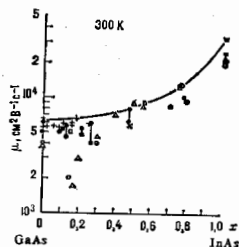


Рис. 2. Зависимость подвижности μ носителей в растворах прямозонных полупроводников GaAs, InAs от концентрации компонентов (x).

В твёрдых растворах, образованных прямозонным и непрямозонным П. м., в области составов, где происходит изменение зонной структуры, наблюдаются резкие изменения свойств (рис. 3).

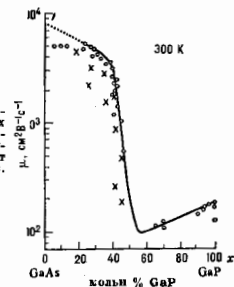


Рис. 3. Зависимость подвижности μ носителей в твёрдых растворах между прямозонным и непрямозонным полупроводниками $\text{GaAs}, \text{P}, \text{As}$ от концентрации компонентов.

Зависимость свойств П. м. от природы и концентрации примесей в дефектов используют для целенаправленного изменения характеристик П. м. путём легирования (см. Легирование полупроводников).

Получение чистых полупроводниковых материалов

Очистка от посторонних примесей в случае Ge и Si осуществляется путём синтеза их летучих соединений (хлоридов, гидридов) с последующей глубокой очисткой методами ректификации, сорбции, частичного гидролиза и термич. обработки. Хлориды подвергают затем высокотемпературному восстановлению водородом, также прошедшим предварит. глубокую очистку, с осаждением восстановленных продуктов на прутках из Ge или Si. Из очищенных гидридов Ge и Si выделяют путём термич. разложения. В результате достигается суммарное содержание остаточных электрически активных примесей $\sim 10^{-4} - 10^{-6}\%$.

Получение особо чистых полупроводниковых соединений осуществляют, применяя для их синтеза очищенные компоненты. Суммарное содержание остаточных примесей в исходных материалах $\sim 10^{-4} - 10^{-6}\%$. Синтез разлагающихся соединений проводят либо в запаянных кварцевых ампулах при контролируемом давлении паров летучего компонента в рабочем объёме, либо под слоем т. н. жидкого флюса (напр., особо чистый обезвоженный борный ангидрид). Синтез соединений, имеющих большое давление паров летучего компонента над расплавом, осуществляют в камерах высокого давления. Часто синтез совмещают с последующей допозит. очисткой соединения путём направленной или зонной кристаллизации расплава. Направленную кристаллизацию осуществляют перемещением контейнера с расплавом в область (зону) с градиентом темп-ры. При зонной плавке расплавленная зона перемещается вдоль кристалла.

Выращивание полупроводниковых монокристаллов

Наиб. распространённым способом является вытягивание из расплава по методу Чохральского (см. Кристаллизация, Монокристаллов выращивание). Этим методом получают монокристаллы Ge, Si, соединений $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{IV}}, \text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{IV}}, \text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{IV}}$ и т. д. Вытягивание монокристаллов неразлагающихся П. м. проводят в атмосфере водорода, инертных газов или в условиях глубокого вакуума. При выращивании монокристаллов разлагающихся соединений (InAs, GaAs, InP, GaP, CdTe, PbTe и др.) расплав герметизируют слоем жидкого борного ангидрида (флюс). Монокристаллы вытягивают, погружая затравку в расплав через флюс и поддерживая в рабочем объёме над расплавом определ. давление инертного газа. Часто вытягивание осуществляют в камерах высокого давления; при этом совмещается процесс выращивания монокристалла с предварит. синтезом соединения под слоем флюса (GaAs, InP, GaP и др.).

Для выращивания монокристаллов П. м. также используют методы направленной и зонной кристаллизации в горизонтальном и вертикальном варианте (индукционный или резистивный нагрев). В случае разлагающихся соединений для получения монокристаллов стехиометрич. состава процесс проводят в запаянных кварцевых ампулах, поддерживая равновесное давление паров летучего компонента над расплавом; часто для этих целей требуются камеры высокого давления, в к-рых поддерживается противодействие инертного газа. При получении монокристаллов необходимой кристаллографич. ориентации используют ориентированные монокристаллич. затравки.

Для выращивания монокристаллов, обладающих благоприятным сочетанием величин плотности и поверхностного натяжения, можно использовать метод бесконтактной зонной плавки. Отсутствие контакта расплава со стенками контейнера позволяет получать наиб. чистые монокристаллы. Обычно процесс выращивания

монокристалла совмещают с предварит. дополнит. зоной очистки. Для создания расплавленной зоны применяют индукционный нагрев (используется в технологии Si).

Для получения монокристаллов ряда тугоплавких релаксирующих полупроводниковых соединений применяют кристаллизацию из газовой фазы методами сублимации и хим. транспортных реакций (напр., CdS, ZnS, SiC, AlN).

Если при выращивании не удается получить соединения стехиометрич. состава, кристаллы разрезают на пластины и подвергают дополнит. отжигу в парах недостающего компонента. Наиб. часто этот приём используют для получения кристаллов узкозонных соединений $A^{IV}B^{VI}$ и $A^{IV}B^{VI}$, где собств. точечные дефекты проявляют высокую электр. активность (PbTe, PbSb_{1-x}Te, Cd_{1-x}Hg_xTe и др.). Для выращивания профилеров монокристаллов П. м. (ленты, прутки, трубы и т. д.) применяют метод Стенована. Процессы получения П. м. в виде монокристаллич. плёнок на разл. родах монокристаллич. подложек наз. процессами эпитаксиального наращивания (см. Эпитаксия).

Применение полупроводниковых материалов

Осн. областью применения П. м. является микроэлектроника. П. м. составляют основу современных больших и сверхбольших интегральных схем (ИС), к-рые делаются в осн. на Si. Повышение быстродействия и снижение потребляемой мощности связаны с созданием ИС на основе GaAs, InP и их твёрдых растворов с др. соединениями $A^{IV}B^{VI}$.

П. м. используют для изготовления «силовых» электронных приборов (вентилей, тристоров, мощных транзисторов). Здесь также осн. П. м. является Si, в дальнейшем продвижение в область более высоких рабочих темп-р связано с применением GaAs, SiC и др. широкозонных П. м. Расширяется применение П. м. в солнечной энергетике. Осн. П. м. для изготовления солнечных батарей являются Si, GaAs, гетероструктуры Ga_{1-x}Al_xAs — GaAs, Cu_{1-x}S — CdS, α -Si(H), α -Si(H) — α -Si_{1-x}C_x(H). С применением кристаллич. гидрированных П. м. связаны перспективы снижения стоимости солнечных батарей.

П. м. используются в пров.-в полупроводниковых лазерах в световых приборах. Лазеры изготавливают на основе ряда прямозонных соединений $A^{III}B^{V}$, $A^{IV}B^{VI}$, $A^{IV}B^{VI}$ и др. Важнейшими П. м. для изготовления инжекционных лазеров являются гетероструктуры: Ga_{1-x}Al_xAs — GaAs; Ga_{1-x}In_xAs_{1-y}P_y — InP; Ga_{1-x}In_xAs — InP; Ga_{1-x}In_xAs_{1-y}P_y — GaAs_{1-x}P_x; Pb_{1-x}Sn_xTe — PbTe (см. Гетероструктуры) для изготовления светодиодов используют GaAs, GaP, GaAs_{1-x}P_x, Ga_{1-x}In_xAs, Ga_{1-x}Al_xAs, SiC и др. П. м. составляют осн. базу фотоэлектрич. устройств широкого диапазона (Ge, Si, GaAs, GaP, InSb, InAs, Ga_{1-x}Al_xAs, Hg_{1-x}Cd_xTe, Pb_{1-x}Sn_xTe и др.). Полупроводниковые лазеры и фотоэлементы — составляющие элементы базы волоконно-оптич. линий связи (см. Волоконная оптика).

Широко используют П. м. для создания разл. приборов СВЧ- и радиодиапазонов (биполярные и полевые транзисторы, транзисторы на горячих электронах, диоднопролетные диоды), детекторов частиц (чистые Ge, Si, GaAs, CdTe и др.; см. Полупроводниковый детектор). На основе П. м. изготавливают термохолодильники, термоэлектрич. высокочувствит. термометры, датчики магн. полей, модуляторы и волноводы ИК-излучения, т. е. оптические окна и др.

Лит.: Горелов И. С., Давиденко И. М., Я. Материаловедение полупроводников и металловедение. М., 1973; Мизнер В. С. и Я. М. Р. Полупроводниковые материалы в современной электронике. М., 1986; Нашельский В. А., Я. М. Технология полупроводниковых материалов. М., 1987; Мейер В. Э., Давыдов С. Д. Электрофизические свойства полупроводников. (Справочник физических величин). М., 1987. М. Г. Мильштейн.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ — общее название разнообразных приборов, действие к-рых основано на свойствах полупроводников — одноволновых (табл. 1) и неоднородных, содержащих $p-n$ -переходы и $heteroperеходы$ (табл. 2, 3). В П. п. используются разл. явления, связанные с чувствительностью полупроводников к внеш. воздействиям (изменению темп-ры, действию света, электр. и магн. полей и др.), а также поверхностные свойства полупроводников (контакт полупроводников — металл, полупроводник — диэлектрик и их сочетания).

Табл. 1. — Полупроводниковые приборы на основе однородного полупроводника

Внешнее воздействие	Используемое явление (свойство)	Название прибора	Число электродов
Свет	Пропускание света выше определ. частоты	Оптич. фильтр	0
»	Генерация носителей заряда под действием света	Полупроводниковый лазер с оптич. накачкой	—
Электронный пучок	Генерация носителей под действием электронов	Полупроводниковый лазер с накачкой электронным пучком	—
Электр. поле E	Электр. проводимость полупроводника; ток $I = \sigma E$	Резистор (сопротивление)	—
»	Свет частоты ω и E магн. поле H	Генератор Гална	2
»	»	Фотосопротивление (фоторезистор)	2
»	»	Сопровождение (резистор), управл. элемент магн. полем	2
»	»	Датчик Холла	4
E, темп-ра T	Зависимость электропроводности полупроводника от темп-ры: $I = \sigma(T)E$	Термистор (терморезистор)	2
E, давление P	Тензорезистивный эффект	Тензодатчик	2

Табл. 2. — Многопереходные полупроводниковые приборы

Внешнее воздействие	Название	Основные особенности	Число электродов
E ₁ или E ₂	Биполярный транзистор	Взаимосвязанные $p-n$ и $n-p$ -переходы	3
E	Диодный тиристор	Четырёхслойная структура $p-p-n-p$	2
»	Триодный тиристор	$p-p-n-p$ -структура с 1 управляющим электродом	3
»	Полевой транзистор с $p-n$ -переходом	Униполярный транзистор с затвором в виде $p-n$ -перехода	4
»	МДП-диод	Диоды с МДП-структурой (переменная ёмкость, световыключающие диоды, приёмники света)	2
»	МДП-транзистор (МДП-триод)	МДП-структура	3

Наряду с П. п., классификация к-рых приведена в табл. 1, 2, 3, к П. п. относят также полупроводниковые *интегральные схемы* — монолитные функциональные узлы, все элементы к-рых изготавливаются в едином технолог. процессе.

Лит.: Пасынков В. В., Чирниц Л. К., Шнигов А. Д. Полупроводниковые приборы, 4 изд., М., 1987; Федотов Я. М., 1970; З и С. М., Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., кн. 1—2, М., 1984.

Табл. 3. — Полупроводниковые приборы с одним $p-n$ -переходом, генератором или переходом металл-диэлектрик

Внешнее воздействие	Используемое явление	Название прибора	Число элементов
Свет	Вентильная фотоодс	Полупроводниковый фотоэлемент, солнечная батарея	2
E	Вольтамперная характеристика $p-n$ -перехода	Полупроводниковый диод-выпрямитель	2
	Зависимость сопротивления $p-n$ -перехода от приложенного напряжения	Варистор (переменная сопротивление)	2
	Зависимость емкости $p-n$ -перехода от приложенного напряжения	Варистор (переменная емкость)	2
	Излучат. рекомбинация электронов и дырок в области гомо- или гетеро- $p-n$ -перехода (спонтанная)	Светоизлучающий диод (электролюминесцентный диод)	2
	N -образная вольтамперная характеристика симметричного (с двух сторон) $p-n$ -перехода (вырождение)	Туннельный диод (уменьшение и генерирование электрич. колебаний с частотами 10 ТГц)	2
	Излучат. рекомбинация (вынужденная) в области гомо- или (чаще) гетеро- $p-n$ -переходов	Исходящий лазер	2
	Резкое возрастание тока чрев $p-n$ -переход из-за лавинного пробоя и туннелирования	Стабилизатор напряжения	2
V	Генерация колебаний СВЧ, связанная с лавинным умножением и задержкой на время пролета	Лавинно-прямительный диод (генератор)	2
	Вольтамперная характеристика контакта металл-полупроводник	Диод Шоттки, диод Мотта, туннельный диод	2
	Генерация электронно-дырочных пар частиц, вылетающей в обедненной носителями слой области контакта полупроводник-металл или между $p-n$ -перехода	Полупроводниковый детектор частиц	6
T	Зависит эффект	Термопара, термогенератор	6
E, T	Пельтье эффект	Холодильник Пельтье	6
Свет, E	Генерация электронов и дырок в области $p-n$ -перехода под действием света	Фотодиод (детектор света и др.)	6

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР — детектор частиц, осн. элементом к-рого является $p-n$ -переход.

П. д. состоит из слоя полупроводника с нанесенными на него с обеих сторон металлы. электродами, на к-рые подается напряжение. При попадании частицы или γ -кванта в полупроводник в нём в результате ионизации образуются неравновесные носители заряда — электроны и дырки, к-рые под воздействием электрич. поля перемещаются к электродам. В результате в электрич. цепи, соединённой с П. д., возникает импульс тока

$$I(t) = \frac{\Delta Q(t)}{\Delta t},$$

где $\Delta Q(t) = \Delta Q_2(t) + \Delta Q_1(t)$ — заряд, наводимый на электродах. Импульс тока преобразуется в импульсы напряжения, амплитуда к-рого пропорциональна энерг. выделению $\Delta \mathcal{E}$ частицы в полупроводнике.

Необходимым условием, обеспечивающим возможность измерения заряда ΔQ , возникающего в П. д. под действием ионизирующей частицы, является малая величина темнового тока I_0 , протекающего через П. д. в отсутствие ионизации. Это означает, что полупроводник должен обладать высоким уд. сопротивлением r .

Если флуктуации темнового тока $\sqrt{I_0 \Delta t / e}$ за время собрания носителей $\Delta t (I_0 \Delta t / e)$ сравнимы с числом носителей N_0 , созданных в объёме П. д. частицей, то выделение полезного сигнала оказывается невозможным. Чем меньше N_0 и чем с большей точностью необходимо измерить ΔQ , тем большим сопротивлением r должен обладать полупроводник. Для измерения энерг. выделенная $\Delta \mathcal{E} = 1$ МэВ с точностью 1% необходимо $r > 10^8$ Ом·см.

Число носителей заряда N_0 , возникающих в П. д. при энерг. выделении $\Delta \mathcal{E}$, равно $\Delta \mathcal{E} / \mathcal{E}_0$, где \mathcal{E}_0 — энергия, необходимая для образования пары электрон-дырка. Т. к. в полупроводниках $\mathcal{E}_0 \sim 3$ эВ, а в газах $\mathcal{E}_0 \sim 30$ эВ, то в П. д. при том же $\Delta \mathcal{E}$ создается в 10 раз больше носителей заряда, чем в газовой иониз. камере. В этом заключается одно из важных преимуществ П. д. перед газовыми детекторами.

Время жизни носителей заряда t должно превышать время сбора Δt заряда на электроды (иначе сбор будет не полным). В полупроводниках, используемых для П. д., времена жизни свободных электронов и дырок t составляют неск. мс, что достаточно для полного сбора носителей. Скорость v сбора носителей или время их сбора Δt определяются подвижностью носителей заряда μ и напряжённостью электрич. поля E : $v = \mu E$. В случае однородного электрич. поля $E = W/d$, где W — толщина чувствит. области. Материал для П. д. не должен содержать большого кол-ва примесных центров, к-рые приводили бы к захвату носителей заряда, образующихся при ионизации.

В природе не существует веществ, к-рые имели бы значения r, μ, t, \mathcal{E}_0 , необходимые для П. д. Диэлектрики обладают высоким r , но очень малым t , поэтому на их основе возможно создание детекторов лишь с тонкой чувствит. областью. Так, на основе алмазов созданы детекторы с толщиной рабочей области $D \leq 300$ мкм. Полупроводники обладают нужными r, \mathcal{E}_0, t , однако их сопротивление r (даже при высокой степени очистки от примесей) оказывается ниже требуемого для обеспечения малого темнового тока (табл.).

Характеристики некоторых полупроводников, применяемых для полупроводниковых детекторов

Вещество ($T=300$ К)	Плотность, г/см ³	\mathcal{E}_0 , эВ		μ , см ² /Вс		t , с	
		\mathcal{E}_0 , эВ	\mathcal{E}_0 , эВ	электроны	дырки	электроны	дырки
Si	2,33	1,42	3,61	1350	480	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Ge (77 К)	5,33	0,79	2,96	$3,6 \cdot 10^4$	$4,5 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
CdTe	6,08	1,47	4,43	1000	80	10^{-7}	$5 \cdot 10^{-7}$
GaAs	5,32	1,42	4,2	$8 \cdot 10^3$	450	10^{-7}	10^{-7}
HgI ₂	6,4	2,13	4,2	100	4	10^{-7}	10^{-7}

Необходимые условия реализуются в области $p-n$ -перехода, обеднённой носителями, где r на неск. порядков выше, чем вне перехода. Обычно толщина области $p-n$ -перехода W , обеднённая носителями заряда, — чувствит. область П. д. — мала ($\leq 10^{-4}$ см). Практич. значения такой $p-n$ -переход не представляет, т. к. пробег R заряд. частиц, как правило, существенно больше l в области $p-n$ -перехода выделяется малая часть энерг. частицы. Для увеличения W на $p-n$ -переход подают обратное смещение U , к-рое увеличивает размер обеднённой области в соответствии с соотношением $W = bV/rU$, где b — константа, характеризующая полупроводник. Так, для n -Si $b = 0,5$. Для p -Si $b = 0,3$, для n -Ge $b = 1$, для p -Ge $b = 0,85$. При этом через $p-n$ -переход течёт темновой ток разл. происхождения: за счёт тепловой генерации электронов и дырок $I_{ген} = \exp(-\mathcal{E}_g/kT)$, где \mathcal{E}_g — ширина запрещённой зоны в полупроводнике; ток диффузии $I_{диф}$ за счёт неравновесной концентрации носителей.

ток поверхностной утечки $I_{\text{пов}}$. Для уменьшения $I_{\text{пов}}$ необходимы материалы с достаточно большой $I_{\text{св}}$ (в случае Ge — охлаждение). Для уменьшения $I_{\text{пов}}$ выбирают спец. геометрию П. д., используют обработку поверхности и разл. покрытия. Наиб. употребит. материалами для П. д. являются Si и Ge.

Типы полупроводниковых детекторов. В зависимости от способа создания $p-n$ -перехода различают поверхности-барьерные, диффузионные и ионно-легированные П. д. В поверхности-барьерных П. д. $p-n$ -переход создается пассивацией на поверхность полупроводника металла испарением в вакууме (см. Шоттки барьер; рис. 1). При определ. значениях r и U можно обеспечить полное обеднение носителями и получить детекторы с чувствит. областью, равной всей толщине пластины полупроводника, вплоть до 2–3 мм. Незудвиг. областями в таких детекторах являются переднее и заднее окна, суммарная толщина к-рых может быть доведена до долей мм.

В диффузионных П. д. переход создается диффузией донорных (или акцепторных) атомов в полупроводник с проводимостью p - или n -типов. Толщина входного окна в диффузионных детекторах существенно больше, чем в поверхности-барьерных, однако переход менее чувствителен к внеш. условиям.

В ионно-легиров. П. д. переход создается внедрением примесных атомов в кристалл при облучения его пучком ионов (см. Ионная имплантация). Обычно внедряется бор в полупроводник n -типа и фосфор в полупроводник p -типа (см. Легирование полупроводников). Толщина входного окна в ионно-легиров. П. д. может достигать величины ~ 1 мм. Для обеспечения высоких характеристик ионно-легиров. П. д. необходим отжиг радиационных дефектов, к-рые возникают при внедрении ионов.

Сущность, увеличение обедненной области в П. д. достигается компенсацией исходного материала до собственной (i) проводимости с помощью дрейфа понов Li в поле $p-n$ -перехода. На основе pin -диода созданы П. д. с толщ. чувствит. области $W = 10-15$ мм и с объемом $V = 100-150$ см³ (рис. 2). Из-за относи-

тельности (для Ge разностная концентрация p - и n -примесей составляет $2 \cdot 10^{20}$ см⁻³). На этой основе созданы т. н. $HPGe$ -детекторы (high purity Ge), для к-рых нет необходимости охлаждения во время хранения, но необходимо охлаждение при работе с целью уменьшения шумов.

Преимущества П. д. по сравнению с др. детекторами: пропорциональность сигнала энергоделиению ΔE частицы в месте П. д. в широком диапазоне E (неск. порядков), малая толщина входного окна, нечувствительность к магн. полю, высокие энергетич. разрешение на счёт малости ϵ_0 , компактность и др. Однако реализация этих характеристик требует применения сложных электронных устройств. По назначению П. д. можно подразделить на спектрометрические, временные, координатные.

Спектрометрические полупроводниковые детекторы. Энергетич. разрешение П. д. определяется: статистич. флуктуациями в числе носителей заряда δN_s ; потерями в собранном заряде за счёт рекомбинации носителей заряда, захвата их ловушками при движении к электродам δN_r ; флуктуациями в потерях энергии во входном окне П. д. $\delta E_{\text{ок}}$; шумами электронных устройств $\delta E_{\text{ш}}$ и в шумами темнового тока $\delta E_{\text{т}}$. Полное разрешение П. д. по энергии равно:

$$\delta E = \left[\delta E_{N_s}^2 + \delta E_{N_r}^2 + \delta E_{\text{ок}}^2 + \delta E_{\text{ш}}^2 + \delta E_{\text{т}}^2 \right]^{1/2}$$

Компонента δE_{N_s} связана с механизмом возникновения и определяет предельное разрешение. П. д. обладает наилучшим разрешением среди детекторов ионизационного типа. Если вся энергия E частицы выделяется в объёме П. д., то энергетич. разрешение, определяемое статистич. флуктуациями в числе носителей, $\delta E_{N_s} = 2,36(\epsilon_0 F) / E$, где F — т. н. фактор Фанона, учитывающий корреляцию в числе носителей. Теоретич. оценки дают $F = 0,09-0,30$ для Ge и $0,05-0,02$ для Si. Эксперим. значения F для Ge и Si равны $0,13$ и $0,02$, при этом есть тенденция к уменьшению F с улучшением качества П. д. и электронных устройств.

Спектрометрия β -частиц (электронов и позитронов) с энергиями $E \leq 1$ МэВ, к-рые имеют пробег в Si $R \leq 1$ мм, осуществляется как поверхности-барьерными П. д., так и Si(Li)-детекторами. В области энергий $E < 100$ кэВ применение полупроводниковых спектрометров предпочтительнее по сравнению с др. β -спектрометрами (рис. 3). Особенностью регистрации электронов с энергиями $E > 100$ кэВ является появление в процессах взаимодействия электронов с веществом γ -квантов, к-рые могут уйти из объёма П. д. (тормозное излучение). Это приводит к неполному выделению энергии первичного электрона в П. д., к появлению «педестала» в регистрируемом спектре и к уменьшению тем самым эффективности регистрации по пику полного поглощения. С увеличением энергии электронов вклад этих процессов растёт, и при энергиях $E \approx 10$ МэВ спектрометрия электронов по пику полного поглощения теряет смысл, т. к. торможение электронов в объёме П. д. приводит к образованию



только высокой подвижности понов Li в Ge и Si при $T = 30^\circ \text{C}$ для литий-дрейфовых П. д. необходима (востоянно) иная темп-ра, для Ge(Li)-детекторов необходима темп-ра жидкого азота, для Si(Li)-детекторов достаточна $T = (-20) - (-10)^\circ \text{C}$. Разработаны методы очистки Si и Ge до состояния, близкого к собств. про-

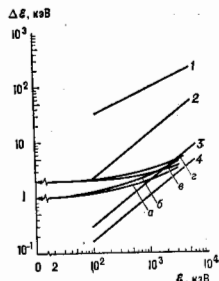


Рис. 3. Энергетическое разрешение ΔE для различных β -спектрометров: 1 — цилиндрического; 2 — магнитного соленоидального; 3 — магнитного с железом; 4 — с магнитным полем; 5 (а, б, в, г) — полупроводниковых спектрометров.

Для больших ϵ , вплоть до неск. сотен МэВ, используются т. н. ливневые спектрометры на основе слоистых систем, включающих слой тяжелого вещества с высоким ат. номером Z (U, Pb), в к-рых происходит активное разможнение электронов и γ -квантов, и слой, состоящие из кремневых П. д. (в виде монокристалла для обеспечения большой площади), в к-рых регистрируются вторичные электроны и γ -кванты. Энергетич. разрешение слоистых ливневых спектрометров $\delta\epsilon$ пропорционально $\epsilon^{-1/2}$.

Спектрометрия α - и К-мезонов, протонов и лёгких ядер для небольших энергий, при к-рых пробеги частиц не превышают неск. мм, осуществляется с помощью Si-детекторов. Для малых ϵ из-за большой величины удельных ионизационных потерь $d\epsilon/dx$ существенна потеря частицей энергии во входном окне П. д. Поэтому здесь предпочтительнее использовать поверхностно-барьерные кремпиевые детекторы. Для α -частиц с $\epsilon = 5$ МэВ лучшее разрешение, достигнутое с использованием Si, составляет $\delta\epsilon \approx 8,5$ кэВ, что всё же в $\sim 1,5$ раза превышает предельное разрешение, обусловленное статистич. флуктуациями в числе ионистей $\delta\epsilon_{ст}$.

Для идентификации частиц по массе используется телескоп из двух (или более) П. д. — т. н. ($\Delta\epsilon - \epsilon$)-система (см. Телескоп счётчиков). Поскольку амплитуда сигнала $\Delta\epsilon$ -детектора пропорциональна $d\epsilon/dx \sim \sim m^{2/3}/\epsilon$, то произведение амплитуд от $\Delta\epsilon$ - и ϵ -детекторов оказывается пропорциональным массе m регистрируемой частицы.

Для спектрометрии диллопробежных частиц (с пробегами $R > 5$ м в Si) применяют как одиночные «толстые» Si- и Ge-детекторы спец. конструкции, так и телескопы «тонких» П. д., имеющих суммарную толщину $\Sigma \Delta x_i > R$. Применение телескопов предпочтительнее перед одиночным «толстым» П. д., т. к.: 1) возможна идентификация частицы по массе по измеренным $\Delta\epsilon$ в отдельных П. д.; 2) возможен отбор случаев, когда частица испытывает ядерное взаимодействие или рассеяние; 3) лучшие временные характеристики. Однако с увеличением энергии частицы (пробега R) вероятность ядерного взаимодействия частицы с веществом П. д. растёт, что приводит к появлению «неустойчивости» в спектре амплитуд. Предельные энергии, когда ещё применяют телескопы П. д., $\epsilon \approx 200-250$ МэВ (для протонов).

Спектрометрия тяжёлых ядер и осколков деления ядер имеет ту особенность, что в этом случае высока уд. ионизация. Это приводит к более медленному разделению положит. и отрицат. зарядов п. следовательно к большой вероятности рекомбинации зарядов на пути частицы, из-за чего возникает ошибка в определении энергии. Степень рекомбинации существенно зависит от ориентации траектории (трека) относительно электр. поля E . Ошибка меньше для трека, расположенного перпендикулярно силовым линиям электр. поля. Для уменьшения эффекта рекомбинации необходимо увеличивать напряжение U на П. д. При спектрометрии тяжёлых ядер и осколков деления важно также иметь мин. толщину входного окна.

Спектрометрия нейтронов осуществляется либо по протонной отдаче (в этом случае перед П. д. располагается водородосодержащая мишень), либо путём регистрации продуктов ядерной реакции, происходящей в самом П. д. или в тонком слое нейтронно-чувствит. материала, расположенного между двумя П. д. В последнем случае обычно используются реакции: ${}^6\text{Li} + n \rightarrow {}^3\text{He} + t + 4,777\text{МэВ}$; ${}^3\text{He} + n \rightarrow p + t + 0,764\text{МэВ}$ (см. Нейтронные детекторы).

Для спектрометрии рентгеновских и γ -квантов при $\epsilon < 100$ кэВ используются планарные Si-детекторы. Для $\epsilon > 100$ кэВ применяются коаксиальные Ge(Li)-детекторы, а также GePC-детекторы (до $\epsilon \sim 10$ МэВ); Ge(Li)-детекторы обладают наилучшим разрешением по энергии: $\delta\epsilon = 1,7$ кэВ для $\epsilon_s = 1$ МэВ (рис. 4).

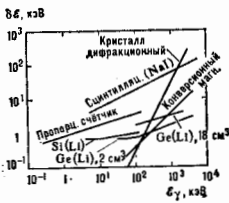


Рис. 4. Зависимость разрешающей способности от энергии γ -квантов для γ -спектрометров разных типов.

С ростом ϵ , (от 10^1 до 10^8 кэВ, см. рис. 5) эффективность регистрации, осуществляемая по пику полного поглощения, падает, т. к. растёт вклад комптоновского фона, что затрудняет выделение слабых линий при исследовании многолинейчатых γ -спектров. В качестве *газла-спектрометров* используются также П. д. на основе CdTe, GaAs, HgTe. Благодаря большому Z такие детекторы имеют большую эффективность регистрации (чем Ge-детекторы), но худшее энергетич. разрешение (из-за большей величины $\epsilon_{ст}$, табл.).

Эти П. д. используются также для регистрации сцинтилляц. излучения вместо фотодетекторного умножителя в комбинации сцинтиллятор — фотодиод (см. Сцинтилляционный детектор). Для $\epsilon_s > 10$ МэВ процесс поглощения энергии в П. д. приобретает ливневый характер; вплоть до энергий порядка сотен МэВ для спектрометрии γ -квантов используются ливневые спектрометры на основе П. д. с радиаторами с большим Z .

П. д. обладают хорошим временным разрешением, сравнимым в нек-рых случаях с разрешением сцинтилляц. детекторов. Для планарных П. д. с $W = 1$ мм время сбора носителей Δt , определяющее временное разрешение, порядка 10 нс.

Координатные полупроводниковые детекторы изготавливаются на основе Si. В т. н. реактивном П. д. координата x прохождения частицы через П. д. определяется по соотношению амплитуд сигналов (E и $E(x)$), снимаемых с разных сторон П. д., на одной стороне к-рого нанесена металл. плёнка, обладающая высокой однородностью по толщине (сопротивлению). Обычно это Au или Pd (рис. 6). Координатное разрешение составляет доли мм.

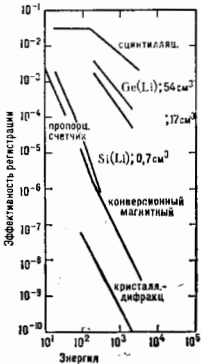


Рис. 5. Зависимость эффективности регистрации γ -квантов от ϵ_s для равных γ -спектрометров.

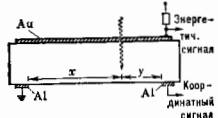


Рис. 6. Схема реактивного детектора ($t = x + y$).

В т. н. стриповых (полосковых) детекторах один из электродов выполнен в виде изолиров. полосок. Стриповые П. д. — одномерные координатные детекторы — обладают координатным разрешением $\Delta x \approx 20$ мкм,

определяемым шириной стрипа. В двумерных стриповых П. д. стрипы нанесены с обеих сторон П. д., но во взаимно перпендикулярных направлениях. Стриповые П. д. применяются в качестве т. н. верхних детекторов для выделения случаев рождения и распада короткоживущих ($\tau = 10^{-13} - 10^{-15}$ с) т. н. очарованных и прелестных частиц и определения их времен жизни и др. характеристик (см. *Комбинированные системы детекторов, Элементарные частицы*). Дальнейшее развитие привело к созданию т. н. пиксельных детекторов с размером ячейки (пикселя) 30×30 мкм на основе *pn*-структуры. Для сокращения каналов электроники разработана полупроводниковая дрейфовая камера на основе *pn*-структуры (рис. 7). Электрич. поле возрастает

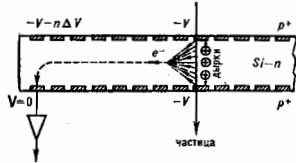


Рис. 7. Дрейфовая камера.

с номером стрипа, а крайняя левая полоска служит анодом. На стрипы подается отрицат. потенциал $-V$ по отношению к ср. плоскости, так что электроны стягиваются к ней и движутся к аноду. Дырки же будут собираться на электродах вблизи трека частицы. Координата определяется по времени дрейфа электронов от места их возникновения до анода. Координатное разрешение полупроводниковой дрейфовой камеры составляет $10 \div 20$ мкм.

П. д. с лавинным усилением заряда имеют внутр. усиление до $10^3 - 10^4$ и обладают лучшими временными характеристиками, чем *ПИС-детекторы*. Перспективы координатные П. д. на основе *лавинно-прямых диодов* с отрицательной обратной связью.

Радиационная стойкость П. д. зависит от вида, интенсивности и энергии излучения. П. д. могут устойчиво работать без ухудшения характеристик при облучении γ -квантами дозой до 10^6 рад. На веск. порядков более чувствительны П. д. к облучению тяжелыми заряж. частицами, а также медленными нейтронами. Ухудшение энергетич. разрешения возникает при потоке протонов (с энергией 5–10 МэВ) порядка 10^6 см $^{-2}$, быстрых нейтронов $\sim 10^{12}$ см $^{-2}$, электронов (с энергией 2–5 МэВ) $\sim 10^{13}$ см $^{-2}$.

Дитт.: Semiconductor detectors, ed. by G. Bertolini, A. Cocchi, Amat., 1968; Vertex detectors, ed. by F. Upla, N. U. 1988; А. и И. и др. Ю. К., Кадьяк А. И., Кушняков В. Ф., Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике, М., 1989; Кляй и не х К., Детекторы корпускулярных излучений, пер. с нем., М., 1980. Г. А. Сокол.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД — см. *Диоды твердотельные*.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР — лазер на основе полупроводниковой активной среды. В отличие от лазеров др. типов, в П. л. используются квантовые переходы между разрешенными энергетич. зонами, а не дискретными уровнями энергии (см. *Полупроводники*). Лазерный эффект в П. л. связан в осн. с межзонной люминисценцией (излучат. рекомбинацией созданных люмин. воздействием избыточных электронов и дырок; рис. 1). Поэтому длину волны λ лазерного излучения можно выразить через ширину запрещенной зоны E_g :

$$\lambda = hc / E_g, \quad (1)$$

где h — постоянная Планка, c — скорость света. П. л. выекают спектральный диапазон от $\lambda \approx 0,3$ мкм до $\lambda \approx 45$ мкм (рис. 2).

В полупроводниковой активной среде может достигаться очень большой показатель оптич. усиления (до 10^4 см $^{-1}$), благодаря чему размеры П. л. исключительно малы, напр. длина резонатора может составлять неск. мкм, типично — 200–300 мкм. Помимо компактности, особенностями П. л. являются малая инерционность ($\sim 10^{-9}$ с), высокий кд ($10 - 50\%$), возможность плавной спектральной перестройки, большой выбор веществ для генерации в широком спектральном диапазоне. К достоинствам П. л. следует также отнести совместимость П. л. с полупроводниковыми приборами др. типов и возможность монолитной интеграции, возможность электронного управления режимом генерации и параметрами излучения — длиной волны, степенью когерентности, числом спектральных мод и т. н., возможность ВЧ-модуляции излучения путем модуляции тока накачки, инновольность ($< 1 - 3$ В) электропитания, а также наибольшую среди лазеров др. типов долговечность (до 10^6 ч).

П. л. включает в себя активный элемент из полупроводникового монокрystalла, чаще всего в форме бруска («пипа»). Собственно активная область элемента обычно составляет лишь его малую часть, и её объем, напр. в соаренном т. н. полосковом, *инжекционном лазере*, оказывается в пределах $10^{11} - 10^{10}$ см 3 . Оптич. резонатор П. л. образован либо торцевыми зеркальными гравиями активного элемента (изготавливаемого обычно путем раскалывания пластин по плоскостям свайности кристалла), либо внеш. отражателями и сложными устройствами с периодич. структурами обратной связи (брагговскими отражателями и структурными распределенной обратной связи).

Накачка. Важнейшим способом накачки в П. л. является инжекция избыточных носителей заряда через *p-n-переход, гетеропереход* или др. нелинейный электрич. контакт. На рис. 3 показан нижекц. лазер с активной полоской, вытянутой вдоль оси оптич. резонатора перпендикулярно двум плоскостеральным торцам лазера. Из-за сравнительно малых размеров излучающего пятна на торце инжекц. лазера искусаемое излучение сильно дифрагирует при выходе во внеш. среду и его направленность оказывается невысокой (угол расходимости лазерного пучка составляет $20 - 40^\circ$ и обычно заметно различается во взаимно ортогональных плоскостях).

Др. способами накачки служат электрич. пробой в сильном поле (напр., в т. н. стримерных лазерах), освещение (П. л. с оптич. накачкой) и бомбардировка быстрыми электронами (П. л. с электронно-лучевой или электронной накачкой). П. л. с накачкой электрич. пробом содержат активный элемент в форме чипа-резонатора с контактами для подведения высоковольтного напряжения. В стримерном П. л. используется пробой при стримерном разряде в однородном полупроводниковом образце высокого сопротивления. Напряжение в этом П. л. подводится в виде коротких импульсов, а излучающее пятно быстро перемещается вслед за головкой (стримером) электрич. разряда.

При использовании оптич. или электронно-лучевой накачки активная область располагается в приповерхностном слое полупроводникового образца, и толщина этой области зависит от глубины проникновения энергии накачки. В зависимости от взаимного расположения пучка накачки и лазерного луча используют как

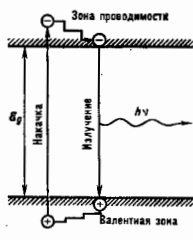


Рис. 1. Межзонная оптический переход в полупроводниках при накачке квантами с энергией, большей E_g .

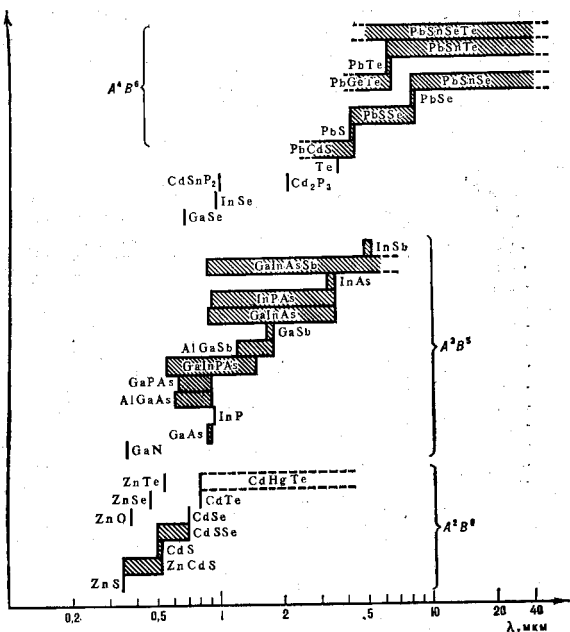


Рис. 2. Полупроводники, используемые в полупроводниковых лазерах, и спектральные диапазоны излучения.

продольный, так и поперечный вариант геометрии накачки. П. л. с электронно-лучевой накачкой помимо активного элемента (мишени) включает в себя электронную пушку. Особенностью лазеров с такой накачкой является возможность быстрого изменения конфигурации накачки, напр. скапирования со скоростью, обеспечивающими воспроизведение телевиз. изображения (лазерное проекц. телевидение).

Физический механизм. Рабочие уровни в П. л. обычно принадлежат энергетич. зонам, т. е. областям сплошного спектра энергетич. состояний, а активными частями лазерной среды являются свободные носители заряда. Накачка обеспечивает поступление избыточных электронов в зону проводимости и избыточных дырок в валентную зону (напр., оптич. накачка порождает избыточные пары носителей — электронов и дырок — за счёт межзонного поглощения; см. в ст. *Полупроводники*). Время свободного пробега носителя обычно мало ($10^{-13} - 10^{-12}$ с) вследствие быстрых процессов внутрizonной релаксации носителей (в частности, электрон-электронных столкновений, рассеяния на фононах и примесях и т. п.). В результате неравновесные носители могут «стериализоваться», т. е. перейти на более низкие энергетич. уровни в пределах своей зоны, распределившись по энергии ϵ в соответствии с ф-цией распределения Ферми для электронов f_n и дырок f_p (см. Ферми — Дирака распределение):

$$f_n = \left(1 + \exp \frac{\epsilon - \epsilon_F^n}{kT}\right)^{-1}; f_p = \left(1 + \exp \frac{\epsilon_F^p - \epsilon}{kT}\right)^{-1}. \quad (2)$$

Здесь T — абс. темп-ра, ϵ_F^n и ϵ_F^p — т. п. квазиуровни Ферми. Образно говоря, электроны «скатываются» к «дну» зоны проводимости ϵ_F^n , а дырки «всплывают» к «поголовку» валентной зоны ϵ_F^p раньше, чем рекомбинируют между собой. Время жизни избыточных носителей, ограниченное рекомбинацией, само по себе довольно мало ($10^{-8} - 10^{-8}$ с), однако оно существенно превышает время свободного пробега и время, необходимое для термализации носителей. Это справедливо и в том случае, когда используется накачка активной среды быстрыми электронами, исходная энергия к-рых составляет $10^4 - 10^6$ эВ. Электроны накачки порождают лавину вторичных неравновесных электронов и дырок, термализующихся к краям своих зон. Время релаксации электронов большой энергии также очень мало из-за возможности расхода энергии на ионизацию (порождение вторичных пар) и на генерацию ВЧ-фононов.

Состояние возбуждённой полупроводниковой среды, при к-ром имеется избыток концентрации носителей, распределённых, однако, в осн. в соответствии с фермиевскими ф-циями f_n и f_p , называется квазиравновесным, подчёркивая тем самым энергетич. равновесность внутри каждой зоны при отсутствии равновесия между зонами.

Мерой отклонения от равновесия концентрации носителей при квазиравновесии служит разность квазиуровней Ферми $\Delta\epsilon = \epsilon_F^n - \epsilon_F^p$. Вынужденные излучат. переходы преобладают над переходами с поглощением, если вероятность заполнения электронами верхних рабочих уровней превышает вероятность заполнения ими ниж. уровней. Это условие сводится к следующему неравенству:

$$f_n(\epsilon + \hbar\nu) > 1 - f_p(\epsilon), \quad (3)$$

где ϵ — энергия ниж. состояния (в валентной зоне), $\epsilon + \hbar\nu$ — энергия верх. состояния (в зоне проводимости); величина $1 - f_p(\epsilon)$ представляет собой вероятность заполнения соответствующего состояния электроном. С учётом (2) для квазиравновесия условие (3) может быть выражено в виде

$$\Delta\epsilon > \hbar\nu, \quad (4)$$

и поскольку для межзонного перехода $\hbar\nu \geq \epsilon_g$, то одновременно выполняется условие

$$\Delta\epsilon > \epsilon_g. \quad (5)$$

Неравенство (5) является условием инверсии для межзонных переходов. Инверсия населённости может быть получена и для переходов между зонами и примесным уровнем или примесными зонами в легиров. полупроводниках, и даже между дискретными уровнями примесного центра (напр., П. л. на триэлектронном переходе в InP, легированном Fe, работающий на длине волны 2,7 мкм при 2 К). Созданы также излучатели когерентного дальнего ИК-излучения, работающие при низкой темп-ре в режиме коротких

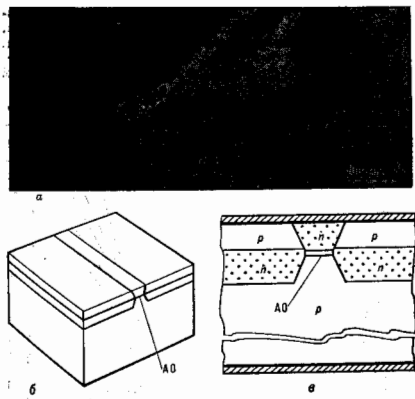


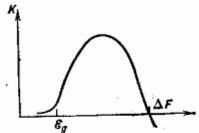
рис. 4. Полосковый инжекционный лазер: а — общий вид в сборке; б — схема; в — сечение вблизи активной области (АО).

випульсов на внутриаэонных переходах в скрещённых электрич. и магн. полях.

Состояние инверсии достигается благодаря действию интенсивной накачки и в случае межзонных переходов выполняется прежде всего для рабочих уровней, находящихся на самых краях обеих зон (в сильнотелегров. полупроводниках — для уровней в «хвостах» зон, протягивающихся в номинально запрещённую зону). Это объясняет справедливость соотношения (1) для большинства лазеров, т. е. объясняет связь энергии фотона лазерного излучения с шириной запрещённой зоны излучающего полупроводника ($h\nu \approx E_g$). Все факторы, оказывающие действие на ширину запрещённой зоны полупроводника (тем-ра, давление, магн. поле), влияют на длину волны лазерного излучения П. л. и одновременно, на показатель преломления среды. Это позволяет осуществлять перестройку длины волны лазерного излучения, напр. для спектроскопич. целей. С др. стороны, для получения лазерного излучения на фиксиров. длине волны необходимо предпринимать меры для её стабилизации, поддерживая на пост. уровне тем-ру, ток накачки и т. п.

Условие инверсии может быть выполнено для фотонов в нек-рой спектральной полосе (рис. 4). Для получения эффекта лазерной генерации оптич. усиление должно компенсировать все потери потока фотонов в пределах лазерного резонатора, образуемого обычно совместно активной средой и зеркальными плоскостями.

рис. 4. Спектральный контур полосы оптического усиления в полупроводниковом лазере.



Такая компенсация достигается прежде всего вблизи максимума усиления, если не применена дополнитель. спектральная селекция, смещающая рабочую частоту лазера. На пороге генерации должны быть выполнены два условия — компенсация энергетич. потерь за счёт оптич. усиления и наличие положит. обратной связи за счёт частичного (или полного) отражения оптич. по-

тока от зеркал обратно в активную среду. Если R — коэф. отражения и K — коэф. усиления на длине активной среды между зеркалами, то условие генерации имеет вид

$$KR \geq 1 \quad (6)$$

(при включении накачки для накопления фотонов в резонаторе необходимо выполнить условие $KR > 1$ в стационарном режиме, если пренебречь вкладом спонтанного излучения $KR \rightarrow 1$). Для естеств. плоской поверхности полупроводникового кристалла, напр. GaAs, $R \approx 0,32$ (если внеш. среда — воздух или вакуум). Следовательно, для возникновения генерации оказывается достаточным $K \approx 3$, что легко можно получить на сравнительно малой длине активной среды (100 — 300 мкм), если учесть, что показатель усиления в полупроводниковой среде легко достигает значений $10^2 - 10^3 \text{ см}^{-1}$.

Материалы и структуры. В П. л. применяются т. н. прямозонные полупроводники (рис. 5, а), в к-рых термализующиеся носители обоих знаков приобретают примерно одинаковый квазимпульс, собираясь в соответствующих экстремумах своих зон и затем излучательно

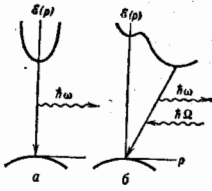


рис. 5. Энергетические диаграммы прямогозона (а) и непрямозонального (б) полупроводников.

рекомбинируя с выполнением закона сохранения квазимпульса (импульс фотона составляет относительно малую величину). В непрямозонных полупроводниках (рис. 5, б) для рекомбинации носителей требуется участие др. частиц или квазичастиц (напр., фононов, обладающих соответствующим квазимпульсом), что существенно снижает вероятность излучат. перехода. В результате получат. переходы не могут конкурировать с безизлучательными. Для непрямозонных полупроводников (к ним относятся, в частности, Si, Ge, SiC, GaP и др.) характерна слабая межзонная люминесценция, в них не развивается усиление, достаточное для возникновения генерации на этих переходах. Попытки создания афф. лазеров на непрямозонных полупроводниках остались безуспешными. Прямозонные полупроводники, используемые в П. л. (рис. 1), относятся в осн. к трём группам соединений: $A^m B^n$, $A^m B^m$, $A^m B^n$ (первые две используются в инжект. П. л.). Кроме бинарных соединений, имеются многочисл. ряды полиморфных твёрдых растворов (на рис. 2 даны их сокращённые ф-лы: напр. GaInPAs означает $Ga_x In_{1-x} P_y As_y$, где x и y — мольные доли соединений Ga и As, соответственно, составляющих многокомпонентную, в данном случае четырёхкомпонентную, смесь).

Среди лазерных материалов выделяются соединения и составы, входящие в т. п. изопериодические пары, т. е. пары кристаллов, различающиеся по хим. составу, ширине запрещённой зоны и др. физ. свойствам, но имеющие одинаковый период кристаллич. решётки. Такие материалы пригодны для образования бездефектных гетеропереходов путём наращивания одного материала на другом эпитаксиальными методами (см. Эпитаксия). Совершенные гетеропереходы необходимы для формирования лазерных гетероструктур, широко используемых в совр. П. л. (наз. также гетеролазерами).

В изопериодич. паре более узкозонный компонент служит в качестве активного вещества и, следовательно

но, должен быть примованным материалом. Более широкозонный компонент выполняет роль эмиттерных слоёв. Подбор изоприводич. материалов среди бинарных соединений весьма ограничен. Лучшей парой являются соединения GaAs (примованное $\epsilon_g \approx 1,5$ эВ) и AlAs (непримованное, $\epsilon_g \approx 2,1$ эВ), у к-рых периоды решётки различаются на 0,14%. В твёрдых растворах бинарных соединений период решётки плавимо зависит от состава; возможности подбора в них изоприводич. пар расширяются. Примером могут служить пара InP ($\epsilon_g = 1,35$ эВ) и $Ga_{0,47}In_{0,53}As = 0,74$ эВ), используемая в гетеролазере на длине волны 1,67 мкм. В четверных и др. многокомпонентных твёрдых растворах существуют неперывные ряды изоприводич. материалов: напр., пара InP — $In_{1-x}Ga_xAs_{1-y}P_y$ перекрывает диапазон длин волн 1,0—1,67 мкм, если между x и y соблюдается «непериодическое» условие $z \approx 2,2x/(1+0,06z)$.

В лазерных гетероструктурах активная область обычно представляет собой тонкий или сверхтонкий (< 100 нм) слой (иногда — неск. таких слоёв с прослойками между ними), заключённый между широкозонными эмиттерными слоями (т. е. двойная гетероструктура). Активный слой обычно обладает свойствами диэлектрика, волноводя, к-рый удерживает поток излучения, расширяя область вдоль него, и уменьшает дифракц. оптич. потери. Активный слой образует собой потенци. яму для избыточных носителей одного или обоих знаков, и в случае особо малой его толщины (< 30 нм) в нём проявляется волновая природа электронов — квантование энергетич. уровней в яме оказывает влияние на спектральную форму полосы усиления. Такие П. л. наз. квантовыми ямами. Уменьшение активного объёма позволяет повысить мощность накачки, необходимую для получения режима генерации. В набв. миниатюрных лазерах пороговый ток генерации составляет ок. 1 мА при комнатной темп-ре, а для получения оптич. мощности 1 мВт достаточен ток накачки 5—10 мА. Распространённым вариантом плазменной лазерной гетероструктуры является двойная гетероструктура с трёхслойным волноводом (рис. 6), в к-рой

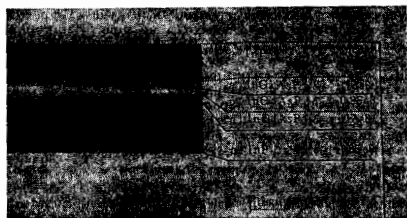


Рис. 6. Двухсторонняя лазерная гетероструктура на основе InGaAsP/InP с трёхслойным волноводом ($\lambda = 1,3$ мкм).

собственно активный слой снабжён тонкими волноводными прослойками. На основе такой модифицированной гетероструктуры достигнуты набв. высокие характеристики инжект. лазера. В т. н. зарачённых или заглублённых полосковых гетероструктурах активный волновод представляет собой полосу, ограниченную гетеропереходами со всех боковых сторон.

В инжект. лазерах удаётся использовать только те лазерные материалы, в к-рых можно получить $p-n$ переход или $p-n$ -гетеропереход, а также возможно обеспечить протекание тока достаточно высокой плотности (10^2 — 10^4 А/см²). К ним не относятся, в частности, примованные соединения типа A^3B^5 в ряд др. полупроводников (Te, GaSe и др.). Ко всем материа-

лам для П. л., однако, применимы бесконтактные способы накачки — оптическая и электронно-лучевая.

Основные характеристики. Мощность излучения П. л. как ф-ция тока накачки (ватт-амперная характеристика; рис. 7) имеет излом на пороге генерации и крутой более или менее линейный участок, наклон к-рого представляет собой дифференц. ватт-амперную эффективность П. л. Пороговая плотность тока в инжект. гетеролазерах на основе GaAlAs/GaAs составляет при комнатной темп-ре 200—500 А/см² при малой толщине активного слоя. В нек-рых образцах П. л. кид (коэф. преобразования электрич. энергии в энергию лазерного излучения) достигает 30—40%. Типичная мощность неперывного излучения полоскового П. л. — ок. 10 мВт, хотя наилучшие ресурсные характеристики (явир., безотказная работа > 10^5 ч) соответствуют мощности 1—3 мВт. Многоэлементные излучатели — фазированные лазерные монолитные «линейки» — обеспечивают мощность лазерного излучения на уровне 5—15 Вт в зависимости от размеров излучателя и числа полосковых элементов. В импульсном режиме мощность излучения ограничивается оптич. прочностью материала (критич. интенсивность излучения в GaAs составляет 2—3 МВт/см² при длительности импульса 10^{-7} с). Пиковая мощность инжект. лазера с широким контактом достигает 20—50 Вт; в лазерах с большим рабочим объёмом, накачиваемых с помощью электронного пучка или излучения др. лазера, мощность излучения в импульсном режиме может достигать 10^5 Вт.

Модовой состав излучения существенно зависит от конструкции и размеров резонатора П. л., а также от величины мощности излучения. П. л. испускает узкую спектральную линию, к-рая сужается с увеличением мощности излучения, если не появляются пульсации и многомодовые эффекты. Сужение линии ограничивается фазовыми флуктуациями, обусловленными спонтанным излучением. Эволюция спектра излучения с ростом мощности в инжект. лазере показана на рис. 7. В одночастотном режиме наблюдаются сужение спектральной линии до 10^2 — 10^3 Гц; мин. значение ширины линии в П. л. со стабилизирующей одночастотного режима с помощью селективного ввеш. резонатора составляет величину ~0,5 кГц. В П. л. путём модуляции накачки удаётся получить модулярное излучение, напр. в форме синусоидальных пульсаций с частотой, достигающей в нек-рых случаях 10—20 ГГц, или в форме УК-импульсов субнанокуандной длительности (10^{-13} — 10^{-12} с). Осуществлена передача информации с помощью П. л. со скоростью 2—8 Гбит/с.

Применение П. л. находят в бытовых и техн. устройствах записи и воспроизведения информации (т. е. оптич. ягла в проигрывателях на компакт-дисках, видео-дисках, в голографич. системах памяти), в лазерных принтерах, волоконно-оптич. системах связи, системах накачки твердотельных лазеров, в автоматич. телеметрич. датчиках, науч. исследованиях, в спектроскопии, спектральных датчиках, оптич. дальнометрах, высотометрах, в проецир. лазерном телевидении, оптич. «сторожах», имитаторах стрельбы, индикаторах

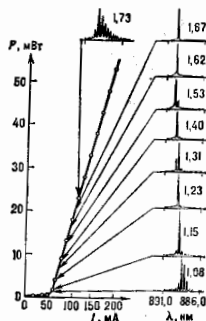


Рис. 7. Ватт-амперная характеристика и эволюция спектров излучения полоскового гетеролазера на основе GaAlAs/GaAs.

и т. д. В заруб. странах годовое потребление П. л. составляет $\sim 10^7$ экземпляров, гл. обр. *гетеролазеров* на основе GaAlAs/GaAs и InGaAsP/InP.

Лит.: Елисеев П. Г., Введение в физику инжекционных лазеров. М., 1983; Басов Н. Г., Елисеев П. Г., Попов Ю. М., Полупроводниковые лазеры. УФН, 1968, т. 148, с. 35.

ПОЛУТЕННЕВЫЕ ПРИБОРЫ — название одного из типов полиметров, в к-рых измерение угла *градиации плоскости поляризации* сводится к визуальному выравниванию яркости двух половин поля зрения прибора. Подробнее см. в ст. *Полиметр*.

ПОЛЫЙ КАТОД — тип эмиттера в газоразрядных приборах, в к-ром ток эмиссии снимается с поверхности полости (сферической, цилиндрической), охватывающей разрядный объём. К П. к. относятся также эмиттеры, состоящие из неск. элементов, рабочие поверхности к-рых ограничивают часть разрядного объёма. Характеристики разряда с П. к. (вольт-амперная, зависимость тока от давления и т. п.) могут резко отличаться от характеристик разряда с плоским катодом, так, напр., ток разряда с П. к. больше тока разряда с плоским катодом (при поддержании пост. напряжения на электродах) [1]. Так же существенно отличаются параметры плазмы внутри катодной полости от параметров в межкатодном промежутке.

Тензорный разряд с П. к. впервые описан как особый тип разряда Ф. Пашеном (F. Paschen) в 1916. В тензорном разряде часто применяют цилиндрич. катоды, а также катоды из двух плоских параллельных пластин. В тензорном разряде с П. к. (ТРПК) возбуждаются интенсивные и в то же время достаточно полные спектры с узкими линиями, что обусловливает его широкое применение для спектральных исследований. Свойства плазмы в ТРПК определяются присутствием высокоэнергичных электронов, ускоренных на катодном падении электронов эмиссии. При малых давлениях газа эти электроны осциллируют в полости, многократно отражаясь от прикатодного барьера, время жизни их внутри П. к. возрастает, что приводит к более эфф. ионизации и возбуждению молекул газа. Форма и размеры полости (в частности, размеры выходного отверстия) существенно влияют на характеристики ТРПК, т. к. определяют уход быстрых электронов из полости. Существует разновидность ТРПК — т. н. *сверхплотный разряд* с высокой плотностью тока на катоде (до 50 А/см^2).

П. в. в дуговом разряде впервые применил Дж. Лус (J. Luce) в 1956. Дуговой П. к. обычно представляет собой узкий длинный цилиндр; высокие плотности тока на выходе полости обеспечиваются за счёт сбора тока с большой внутр. поверхности, граничащей с плазмой. Дуговой П. к. устойчив к образованию катодных пятен в широком диапазоне условий.

При работе дугового П. к. в атмосфере щелочных (или щелочноземельных) металлов (или при их присутствии в рабочем теле в качестве малой добавки) слегка адсорбированных на стенке П. к. атомов щелочного металла заметно уменьшается работа выхода материала катода, что позволяет понизить темп-ру поверхности до $1000\text{--}1500 \text{ К}$ и резко снизить эрозия.

В дуговом разряде с П. к. возникает плотная плазма; теория процесса основана на раздельном описании узких неравновесных прилегающих слоёв и почти равновесной плазмы, занимающей осн. часть полости [2].

При подаче рабочего тела в разряд через катодную щель создаётся высокая концентрация плазмы в полости при произвольно малом давлении в разрядной камере. В дуговом разряде с П. к. осуществляется распределённый разряд с термоэлектронным механизмом эмиссии. Разогрев стенки катода до высоких темп-р происходит в осн. за счёт южного тока из плазмы, к-рый составляет заметную часть (десяти %) полного тока. Южный ток из дугового разряда с П. к. монотонно растёт при увеличении напряжения, приложенного

к полости, достигая предельных значений порядка хаотич. электронного тока. Рост тока обусловлен увеличением длины $L_{\text{д}}$ области, за счёт плазмы. Увеличение давления плазмы в полости приводит к уменьшению длины $L_{\text{д}}$, и слабо сказывается на вольт-амперной характеристике дугового разряда с П. к. Многополостный дуговой П. к. обеспечивает б-шую эфф. плотность тока на выходе, чем однополостный (при прочих равных условиях).

Лит.: 1) Москалев Б. И., Разряд с полым катодом. М., 1969; 2) Басов Ф. Г. и др., Дуговой полный катод с сильноионизованной плотной плазмой, ЖТФ, 1966, т. 36, с. 81.

ПОЛЮС *фун. к-ции* — изолированная особая точка аналитич. функций, характеризующаяся тем, что предел функций в этой точке равен бесконечности. Если $f(z)$ имеет полюс в точке z_0 , то в окрестности z_0 разлагается в *Лорана ряд*, содержащий конечное число членов с отрицат. индексами:

$$f(z) = a_{-n}(z-z_0)^{-n} + \dots + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots,$$

где $n \geq 1$ и $a_{-n} \neq 0$. Число n наз. порядком полюса, а коэф. a_{-1} — вычетом ф-ции $f(z)$ в точке z_0 . Если $n = 1$, то соответствующий полюс наз. простым.

Лит. см. при ст. *Аналитическая функция*. Б. И. Завлаев.

ПОЛЮС МАГНИТНЫЙ — см. *Магнитный полюс*.

ПОЛЯ ТЕОРИЯ — см. *Векторный анализ*.

ПОЛЯ ФИЗИЧЕСКИЕ — физ. системы, обладающие бесконечно большим числом степеней свободы. Относящиеся к такой системе физ. величины не локализованы на к. л. отдельных материальных частях, а конечным числом степеней свободы, а непрерывно распределены по нек-рой области пространства. Примерами таких систем могут служить гравитат. и эл.-магн. поля и волновые поля частиц в квантовой физике (электронно-позитронное, мезонное и т. п.). Для описания П. ф. в каждый момент времени необходимо задать одну или неск. физ. величин в каждой точке области, где имеется поле, т. е. задать полевою ф-цию. Пока речь идёт о нерелятивистских процессах, понятие поля можно не вводить. Напр., при рассмотрении гравитат. или кулоновского взаимодействия двух частиц можно считать, что сила взаимодействия возникает лишь при наличии обеих частиц, полагая, что пространство вокруг частиц не играет особой роли в передаче взаимодействия. Такое представление соответствует концепции дальнего действия, или действия на расстоянии. Понятие о дальнем действии, однако, является приближением, только в нерелятивистском случае физически эквивалентным представлению о том, что действие заряда проявляется лишь при помещении 2-й, пробной, частицы в область пространства, свойства к-рого уже изменены из-за наличия 1-й частицы. Взаимодействие при этом передаётся по-прежнему, от точки к точке, в таком изменённом пространстве. Это и означает, что 1-я частица создаёт вокруг себя силовое гравитат. или эл.-магн. поле. Эта концепция близкого действия находит подтверждение при рассмотрении релятивистских процессов. В этом случае, т. е. при движении источников со скоростью, сравнимой со скоростью передачи взаимодействия, говорить о дальнем действии уже нельзя. Именно, изменение состояния одной частицы сопровождается, вообще говоря, изменением её энергии и импульса, а изменение силы, действующей на др. частицу, наступает лишь через конечный промежуток времени. Доля энергии и импульса, отданные одной частицей и ещё не принятые 2-й, принадлежат в течение этого времени переносимому их полю. Поле, переносящее взаимодействие, является, т. о., само по себе физ. реальностью.

Понятие поля применимо при описании свойств всякой сплошной среды. Если сопоставить с каждой точкой среды определяющие её состояние физ. величины (темп-ру, давление, натяжения и т. п.), то получатся поле этих величин. В этом случае роль упругой среды для передачи взаимодействия очевидна. Перович.

трудность представить себе немеханич. средю, способную переносить энергию и импульс, породила разл. механич. модели эфира как среды, переносящей эл.-магн. взаимодействия. Однако все механич. модели эфира противостоят принципу относительности Эйнштейна (см. *Относительности теория*), и от них пришлось отказаться.

Простейший тип движения поля — волновое, для к-рого полевая ф-ция периодически меняется во времени и от точки к точке. Вообще, любое состояние поля удобно представить в виде суперпозиции волн. Для волнового движения характерны явления дифракции и интерференции, немеханич. в классич. механике частил. С др. стороны, динамика, характеристики (энергия, импульс и т. д.) волн «размазаны» в пространстве, а не локализованы, как у классич. частил.

Такое противопоставление волновых и корпускулярных свойств, присущее классич. механике, отражается в ней как качеств. различие между П. ф. и частицами. Однако опыт показывает, что на малых расстояниях, в атомных масштабах, это различие исчезает: у волн выявляются корпускулярные свойства (см., напр., *Комптона эффект*), у частил. — волновые (см. *Дифракция частил.*).

Квантовая механика ставит в соответствие каждой частице поле эл. волновой ф-ции, дающее распределение различных, относящихся к частице физ. величин. Концепция поля является основой для описания свойств элементарных частил и их взаимодействий. Конечная цель в этом случае — нахождение свойств частил на ур-ний поля и *перестановочных соотношений*, определяющих квантовые свойства материи. Возможный вид ур-ний поля ограничен принципами симметрии и инвариантности, являющимися обобщением эксперим. данных. Лоренц-ковариантность, напр., требует, чтобы волновые ф-ции частил преобразовались по неприводимым представлениям группы Лоренца. Таких представлений бесконечно много, однако только часть из них реализована в природе и соответствует тем или иным элементарным частилам. Реально используются наиб. простые ур-ния полей, являющиеся локальными и перенормируемыми. Попытки построения теорий, не удовлетворяющих этим требованиям, — нелинейная, нелокальная и т. п. теорий поля — влекут за собой пересмотр ряда важнейших принципов, существующих при физ. интерпретации теории (принцип суперпозиции, положительность нормы волновой ф-ции и т. д.).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантовых полей, 4 изд., М., 1984; Мейджер В. В., Начала теоретической физики, М., 1977; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Квантовые поля, М., 1980, в. 1, 2.

ПОЛЯ ЭФФЕКТ — изменение проводимости *а* полупроводника при наложении эл. поля, перпендикулярного его поверхности. Если одной из обкладок плоского параллельного конденсатора является полупроводник *n*-типа, а другой — металл, и если металл зарядить положительно, то полупроводник заряжается отрицательно, т. е. в его приповерхностном слое появляются избыточные электроны, к-рые вместе с электронами, находящимися в объёме полупроводника, будут участвовать в электропроводности, увеличивая её (за исключением электронов, захваченных на поверхностные уровни). П. э. может быть как положительным, так и отрицательным.

Лит. см. при ст. *Полюризация*.

ПОЛЯРИЗАТОР — устройство для получения полностью или (реже) частично поляризованного оптич. излучения и излучения с произвольными поляризац. характеристиками (см. *Поляризация света*). П. — простейший поляризац. прибор и один из осн. элементов более сложных приборов такого типа. Действие *а* л я е й н ы х П., дающих плоскополяризов. свет, основывает-

ся на одном из трёх физ. явлений: *двойное лучепреломление*, линейный *дихроизм* и поляризация света при отражении (см. *Отражение света*, *Френеля формулы*). Явление двойного преломления используется для разделения двух ортогональнополяризов. лучей в *поляризационных призмах* — д в у пр е л о м л я ю щ и х П.; дихроизм лежит в основе действия *поляридов* — д и х р о и ч е с к и х П.; зависимость коэф. отражения при наклонном падении света на границу раздела двух сред от состояния поляризации определяет поляризующую способность *оптической столы* — о т р а ж а т е л ь н ы х П., а также интерференционных П.

Для получения света, поляризованного по кругу, обычно применяют совокупность линейного П. и четвертьволновой фазовой пластинки (см. *Компенсатор оптический*).

П., как определённый конструктивный элемент оптич. схемы, может использоваться как для создания поляризов. света, так и для анализа света произвольной поляризации (*анализатор*; см. также *Поляризационные приборы*).

ПОЛЯРИЗАЦИИ ВЕКТОР (поляризация) — плотность эл.электрич. дипольного момента среды, усреднённого по физически малому объёму. Причины возникновения поляризации сред разнообразны, напр. внеш. эл.электрич. поле (см. *Поляризация среды*), деформация (см. *Пьезоэлектрики*) и нагрев (см. *Пироэлектрики*). Пространственное распределение П. в *P* (р) однозначным образом определяет плотность связанного эл.электрич. заряда $\rho(r) = -\text{div } P(r)$. В случае процессов, переменных во времени, наряду с П. в. вводится плотность тока поляризации $j_p = \partial P / \partial t$. Подробнее о П. в. см. в ст. *Диэлектрики*.

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ГОЛОГРАФИЯ — метод запаса, воспроизведения и преобразования состояния и степени поляризации поля когерентных эл.-магн. волн. Основан на отображении поляризации суммарного поля опорного и объектного источников излучения поляризационно-чувствительными регистрирующими средами [эффект Вейгера — индуцированная линейно поляризованным светом анизотропия (фотоанизотропия)]; неллинейный эффект Вейгера — индуцированная циркулярно поляризованным светом *гиротропия* (фотогиротропия)].

При сложении волн, имеющих параллельные поляризации, происходит модуляция лишь интенсивности (картина интерференции), что используется в скалярной голографии [1, 2] (рис. 1, а, б). При сложении волн, имеющих ортогональные поляризации, происходит



Рис. 1. Проекционные картины электрического вектора при сложении двух волн различной поляризации: параллельные линейная и циркулярная поляризации (а, б) и ортогональные линейная и циркулярная поляризации (в, г) складываемых волн.

модуляция состояния поляризации при отсутствии модуляции интенсивности (рис. 1, в, г), что может быть отображено только поляризационно-чувствит. средой. В П. г. в общем случае сложения опорной и объектной волн произвольных поляризацй наряду с параллель-

ной опорной волне компонентой электрич. вектора объектной волны регистрируется также ортогональная его компонента, что позволяет смоделировать в голограмме векторный характер поля стоячих волн [3, 4]. При этом пространственно-переменное состояние поляризации суммарной волны вызывает в среде возникновение соответственно переменной фотондуциров. анизотропии и гиротропии. В процессе поляризационно-голографич. воспроизведения поле объекта восстанавливается наряду с амплитудой и фазой также по состоянию и степени поляризации. Поляризац. голограмма может быть получена как в попутных (схемы Габо́ра, Лейта), так и во встречных лучах (схема Денсюка). В зависимости от времени запоминания среды возможна поляризац. голографич. запись как в статич., так и в динамич. режимах [5, 6].

Теоретич. описание П. г. требует существ. усложнения матем. аппарата сравнительно со скалярной голографией. Соединение векторно-матричного метода Дювоиса с поляризац. обобщением Гольдсмита — Френеля принципа позволяет reformулировать дифракц. интеграл Кирхгофа в векторном виде, что даёт возможность анализировать поле при дифракции на структурах неанізотропного характера, в т. ч. на поляризац. голограмме (см. Дювоис матричный метод [7]):

$$E_{\text{об}} = \frac{ik}{4\pi R} \iint_{S_0} n \begin{pmatrix} (1+n) - i^2 & -im \\ -im & (1+n) - m^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{1-1} & 0 \\ 0 & \sqrt{1-m^2} \end{pmatrix} \times \\ \times M E_0 \exp [i(\omega t - kR)] dS_0, \quad (1)$$

где $\omega = 2\pi/T$, $k = 2\pi/\lambda$, T — период колебания, λ — длина волны, M — матрица Дювоиса дифрагирующего объекта, E — вектор Дювоиса просвечивающей волны, $R = R(x, y, z, x_0, y_0)$ — расстояние от объекта до точки наблюдения; i, m, n — направляющие косинусы волнового вектора от объекта до точки наблюдения, S_0 — область, занятая объектом.

Колличеств. описание индуцированных в среде анизотропии в зависимости от энергии и состояния поляризации излучения, действующего на среду и процессе записи, показывает, что под действием активного излучения эллиптич. поляризации первоначально изотропная и негиротропная среда в общем случае становится подобной гиротропному кристаллу. При этом в трёх её сечениях в направлении воздействия активного излучения и в перпендикулярных направлениях комплексный коэф. преломления принимает значения [8]:

$$\hat{n}_1^2 - \hat{n}_0^2 = \hat{s}(I_1 + I_2) \pm \sqrt{[\hat{v}_1(I_1 - I_2)]^2 + \hat{v}_0^2(I_+ - I_-)^2}, \\ \hat{n}_2^2 - \hat{n}_0^2 = \hat{s}(I_1 - I_2) \pm \hat{v}_L(I_+ \mp I_2), \\ \hat{n}_3^2 - \hat{n}_0^2 = \hat{s}(I_1 + I_2) \mp \hat{v}_L(I_1 \mp I_2),$$

где n_0 — исходный коэф. преломления; \hat{s}, \hat{v}_L и \hat{v}_0 — коэф. реакции поляризационно-чувствит. среды, обусловившие соответственно изотропный, анизотропный и гиротропный отклики на действующую интенсивность эллиптич. поляризации; $I_1 + I_2, I_1 - I_2$ и $I_+ - I_-$ — соответственно первый, второй и четвёртый Стокса параметры действующего излучения.

Развита последоват. теория П. г. в двумерных в трёхмерных поляризационно-чувствит. средах, основывающаяся на (1), (2), а также проведены эксперим. исследования, позволяющие сделать ряд заключений. 1. Имеет место асимметрия в состояниях поляризации восстановленного и сопряжённых изображений. В частном случае ортогонально- и циркулярно-поляризованных опорной и объектной волн сопряжённые изображения не возникают. 2. Состояние поляризации опорной волны оказывается необходимым согласовать с коэф. реакции среды. Существенно важно, что как при

наличии только фотанизотропии ($\hat{v}_L \neq 0; \hat{v}_0 = 0$) или только фотогиротропии ($\hat{v}_L = 0; \hat{v}_0 \neq 0$), так и в общем случае ($\hat{s} \neq 0; \hat{v}_L \neq 0; \hat{v}_0 \neq 0$) произвольное пространственно-переменное по поляризации поле объекта возможно адекватно восстановить. При неогласовании со свойствами среды опорной волне не имеет место преобразование состояния поляризации восстановленного поля. 3. Использование неполяризованной опорной волны позволяет неизвестности степень поляризации частично поляризованного, а также микроструктуру неполяризованного волнового поля объекта.

С помощью П. г. решается ряд ранее неизвестных задач. Преобразование состояния поляризации восстановленного изображения даёт информация о векторных коэф. фототракции, и в конечном итоге о фотоструктурных элементарных центрах регистрирующей среды. Это особенно перспективно в совокупности с динамич. режимом записи, когда практически любая среда оказывается способной голографически записать и воспроизвести поле эл.-магн. волн (см. Динамическая голография). П. г. может быть использована в изучении напряжённого и деформированного состояния реал. объектов и конструкций. Методами П. г. возможно создание дифракц. элементов с перем. профилем анизотропии и гиротропии. Подобные структуры способны различать поступающее на них поле пространственно-переменной поляризации на ортогональном базисе, выделяя компоненты базиса соответственно в положительн. и отрицат. порядки дифракции (рис. 2). Обращение волнового фронта в П. г. может быть использовано для



Рис. 2. Картина дифракции сложнопolarизованного объекта на решетке анизотропного профиля (неодиффракция по сечению кристалла рубина). В центре — недиффракционный, нулевой порядок, ослабленный нейтральным фильтром. Слева и справа от него — диффракционные изображения соответственно +1-го и -1-го порядков. Взаимно дополнительный по интенсивности характер этих изображений индуцирует распределение право- и левозакручено поляризованных участков сечения кристалла.

коррекцию генерируемого лазером излучения со сложным распределением поляризации по фронту. Представляется перспективным применение П. г. в гиротропных и анизотропных экспериментах, в задачах переработки оптич. информации и создания оптич. памяти. Избыточность отображённой на поляризац. голограмме исходной информации (интенсивность, ориентация, экспансионсизит, направление вращения эллипса поляризации) свидетельствует о принципиально новых возможностях гибкой и оперативной её переработки во мн. приложениях [9 — 11].

Лит.: 1) О'Авог Д. A new microscopic principle. «Nature», 1948, v. 161, p. 777; 2) Денсюк Ю. Н., Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле рассеянного излучения. «ДАН СССР», 1962, т. 144, в. 6, с. 1275; 3) Как и чаша в я и я. Ш. Д., О поляризационной записи голограмм. «Оптика и спектроскопия», 1972, т. 33, № 2, с. 324; 4) его же, Метод фазовой поляризационной записи голограмм. «Квантовая электроника», 1974, т. 1, № 6, с. 1435; 5) Weigert F., Über einen neuen der Strahlung in lichtoptischen Schichten. «Verhand. Deutsch. Phys. Ges.», 1918, Bd 21, S. 479; 6) Висклпнг А. D., Birefringence resulting from the application

of an intense beam of light to anisotropic medium, «Proc. Phys. Soc.», 1956, v. B 69, p. 344; 7) К а н я ч а в и л и Ш. Д., Поляризационная голография, «ФОН», 1978, т. 126, в. 4, с. 681; 8) Е р о м о, О закономерности в явлениях фотоанізотропии и фототропии, «Оптика и спектроскопия», 1987, т. 63, № 4, с. 911; 9) J o n a t h a n J. M., M a y u M., Interferograms generated by anisotropic photographic recording of two partially coherent vibrations perpendicularly polarized, «Appl. Opt.», 1980, v. 19, № 4, p. 624; 10) Т о д о р о в Т. е. а., Polarization holography for measuring photoinduced optical anisotropy, «Appl. Phys.», 1983, v. B 32, № 2, p. 93; 11) А с т и а М., J o n a t h a n J. M. C., Anisotropic gratings recorded from two circularly polarized coherent waves, «Opt. Commun.», 1983, v. 47, № 2, p. 85.

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ — см. в ст. Микроскопия.

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД исследования напряжений (метод фотоупругости) — экспериментальный метод исследования напряженно-деформиров. состояний элементов машин и конструкций на прозрачных моделях из оптически чувствит. материалов. Метод основан на искусств. врем. двулучепреломлении — свойстве большинства прозрачных изотропных материалов (стекла, целлулоида, желатина, пластмасс) под действием нагрузки становиться оптически анизотропным. Оптич. анизотропию среды можно полностью охарактеризовать эллипсоидом показателей преломления. Три гл. показателя преломления n_1, n_2, n_3 образуют три полуоси эллипсоида, направления к-рых совпадают с направлениями гл. осей тензора напряжений $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$:

$$\begin{aligned}n_1 - n_0 &= C_1 \sigma_1 + C_2 (\sigma_2 + \sigma_3), \\n_2 - n_0 &= C_1 \sigma_2 + C_2 (\sigma_1 + \sigma_3), \\n_3 - n_0 &= C_1 \sigma_3 + C_2 (\sigma_1 + \sigma_2),\end{aligned}\quad (1)$$

где n_0 — коэф. преломления напряженного тела, C_1 и C_2 — оптич. коэф., характеризующие для данного материала зависимость между двойным лучепреломлением и напряженным состоянием.

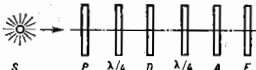
В пластинке, нагруженной в своей плоскости, напряжение σ_3 , направленное нормально к ней, равно нулю. При этом одна из гл. плоскостей оптич. симметрии совпадает с её плоскостью. Для света, падающего перпендикулярно к плоскости пластинки, ур-ния (1) принимают вид

$$\begin{aligned}n_1 - n_0 &= C_1 \sigma_1 + C_2 \sigma_2, \\n_2 - n_0 &= C_1 \sigma_2 + C_2 \sigma_1.\end{aligned}\quad (2)$$

Относит. оптич. разность хода $\Delta = d(n_1 - n_2)$ или $\Delta = Cd(\sigma_1 - \sigma_2)$ — ур-ние Вертгейма, к-рое является основным при решении плоских задач оптич. методом (d — толщина пластинки, C — относит. оптич. коэф. напряжений).

Оптич. свойства нагруженной пластинки определяют при просвечивании её в полярископ. Различают круговые и линейные (плоские) полярископы. Круговой полярископ (рис. 1) включает: источник света S (моно-

Рис. 1. Схема полярископа; D — диафрагма, E — экран.



хроматический — газоразрядные лампы со светофильтрами или источник белого света — лампы накаливания); поляризатор P , после прохождения к-рого свет становится линейно поляризованным; пластинку в четверть длины волны $\lambda/4$, преобразующую линейно поляризованный свет в свет, поляризованный по кругу; систему линз, дающую параллельный пучок света; компенсирующую пластинку в четверть длины волны $\lambda/4$, по прохождении через к-рую снова получаем линейно поляризованный свет; анализатор A , пропускающий свет только с одним направлением колебаний светового век-

тора; систему линз, проектирующую изображение на экран. В пространстве между пластинками в четверть длины волны (рабочее поле кругового полярископа) имеем параллельный пучок света, поляризованного по кругу. Если в круговом полярископе убрать пластинки в четверть длины волны, то в рабочем поле получим параллельный пучок линейно поляризованного света, т. е. плоский полярископ. Интенсивность освещенности экрана кругового полярископа с монохроматич. источником света

$$I_N = I_0 \sin^2(\pi \Delta / \lambda),$$

где I_0 — интенсивность света, вышедшего из поляризатора, λ — длина волны источника света. В точках интерференц. появления пластинки (нагруженной модели), в к-рых $\Delta = m\lambda$ ($m = 1, 2, 3, \dots$), наблюдается погашение света, в точках, где $\Delta = (2m + 1)\lambda/2$ — макс. освещенность. На изображении модели (рис. 2) получаются светлые и темные полосы разных порядков



Рис. 2. Картина полос при растяжении пластинки с круглыми отверстиями.

m (картина полос). Точки, лежащие на одной полосе, имеют одинаковую разность гл. напряжений: $\sigma_1 - \sigma_2 = \Delta / Cd = m\lambda / Cd = m\sigma_0$. Здесь σ_0 — цена полосы модели, т. е. величина разности гл. напряжений в модели, вызывающая разность хода $\Delta = \lambda$. Цена полосы $\sigma_0 = \lambda / Cd$ и относит. оптич. коэф. C характеризуют оптич. чувствительность материала и являются постоянными при пост. темп-ре (σ_0 при одинаковых d и λ).

Для определения направления гл. напряжений σ_1 и σ_2 модель помещают в линейный полярископ. Интенсивность освещенности экрана линейного полярископа с пластинкой в рабочем поле рассчитывается по ф-ле

$$I_N = I_0 \sin^2(\pi \Delta / \lambda) \cdot \sin^2 2\varphi,$$

где φ — угол между направлением плоскости колебаний светового вектора \vec{E} , вышедшего из поляризатора, и направлением одного из гл. напряжений σ_1 или σ_2 . При $\varphi = 0$ или $\varphi = \pi/2$ (плоскость пропускания поляризатора совпадает с направлением σ_1 или σ_2) экран затемнен независимо от величины Δ . Т. о. в темных точках на интерференц. изображении модели направление σ_1 или σ_2 совпадает с плоскостью пропускания поляризатора. Поскольку направление σ_1 и σ_2 меняется непрерывно, точки с одинаковыми направлениями σ_1 и σ_2 лежат на непрерывных темных линиях — т. н. изоклинах. При сплошном повороте скрещенных поляризатора и анализатора изоклины меняют своё положение. Поэтому можно построить поле изоклин для разл. углов φ наклона поляризатора к горизонтальной оси.

Описанный метод определения разности $\sigma_1 - \sigma_2$ наз. методом полос и является более простым, но менее точ-

ном по сравнению с методами компенсации, где для измерения Δ используются клиновье, поворотные, механич. компенсаторы, а также способы гониометрич. компенсации. Т. о., член оптич. измерений можно определить разност. к. напряжений $\sigma_x - \sigma_y$ и их направление. В случаях, когда необходимо знать все три компонента тензора напряжений в отдельности, применяются разл. методы разделения нормальных напряжений: численные, графические и экспериментальные.

Оптически чувствительные материалы, применяемые для изготовления моделей, должны иметь высокую прозрачность, оптич. и механич. изотропию, стабильные оптико-механич. характеристики и необходимую прочность. Их можно разделить на три группы: стекла, полимеры, прозрачные металлы — галлоиды серебра, таллиды и их сплавы — материалы кристаллич. строения.

П.-о. м. применяется также для решения объёмных задач. При этом измерения оптич. величин, связанных с напряжениями [ур-ния (1)], необходимо проводить по толщине объёмной модели; что крайне трудно, а часто практически невозможно. Поэтому для решения объёмных задач существуют методы: «замораживания» деформаций с последующей расфокусировкой на тонкие срезы, оптически чувствительных вклеек, рассеянного света, интегральной фотопрозрачности. Эти методы позволяют определять напряжения внутри модели. Наиб. распространение получил метод «замораживания».

Исследования проводят на трёхмерных моделях из полимерных материалов, имеющих сетчатую структуру (напр., отвержденные эпоксидные смолы и др.), к-рые при комнатной темп-ре находятся в стеклообразном, а при повышенной ($100-140^\circ\text{C}$) — в высокоэластич. состоянии. В высокоэластич. состоянии полимер деформируется упруго. Если нагреть модель на такую температуру, а затем охладить под нагрузкой, то упругие высвобождения, деформация и обуславливаемая ими оптич. анизотропия сохранятся при снятии нагрузки и при разрезе модели на тонкие пластинки (срезы). Оптич. анизотропию в срезах (относит. разность хода Δ и направления плоскостей поляризации лучей) измеряют в полярископах описанными способами и определяют величину разности псевдоглавных напряжений и их направления в плоскости среза:

$$\Delta z = C_T d \frac{(\sigma'_x - \sigma'_y)}{1 - \nu}$$

Если срез совпадает с плоскостью $z = \text{const}$, то σ'_x и σ'_y — макс. и мин. напряжения на площадках, перпендикулярных плоскости среза, d — толщина среза, C_T — оптич. коэф. материала при темп-ре исследования. Просвечивание трёх взаимно перпендикулярных срезов (или одного из трёх направляющих) позволяет определить три разности нормальных напряжений — $\sigma_x - \sigma_y$, $\sigma_y - \sigma_z$, $\sigma_z - \sigma_x$ и три касат. напряжения в выбранной системе координат.

П.-о. м. применяется к исследованию ряда др. задач механики твёрдого деформируемого тела. Фотографический способ исследования упругопластич. задач на прозрачных моделях П.-о. м. Наиб. применение нашли целлулоид, полистирол, поликарбонат, прозрачные металлы. Напр., поликарбонат имеет диаграмму растяжения, характерную для поликристаллич. материалов. В зоне упругих деформаций наблюдается линейная связь между двойным лучепреломлением и напряжениями, в пластической — эта зависимость имеет более сложный вид, определяемый тарировкой материала.

Фотоползучесть — исследование задач ползучести на прозрачных моделях. Этот способ развивается в двух направлениях: прямое моделирование, когда изучаются модель, материал к-рых обладает реологич.

свойствами, подобными свойствам материала натуральных объектов; косвенное моделирование, когда задача решается на основе методов упругих аналогов.

Фототермоупругость — применение П.-о. м. для изучения термоупругих напряжений. Разработан ряд способов. Наиболее распространено исследование тепловых напряжений на прозрачных нагреваемых или охлаждаемых моделях (геометрически подобных), в к-рых создаются температурные поля, подобные натуре. Эффективным является метод «замораживания» — «размораживания» деформаций. Плоская или объёмная модель составляется как монолитная склейка элементов из оптически чувствительного материала, в к-рых предварительно созданы и заморожены деформации, соответствующие свободным тепловым перемещениям. Нагрев склейки модели приводит к «размораживанию» деформаций и установлению искомого напряжённого состояния, фиксируемого затем путём охлаждения модели.

Разработаны также способы фиксации оптич. анизотропии, вызванной тепловыми напряжениями, при облучении моделей γ -лучами. Это позволяет моделировать задачи пространственной термоупругости (метод радиан. фототермоупругости). Применение скоростных клинометров и синхронизирующих устройств, согласующих во времени динамику нагружения модели и съёмку картин полос, вызванных упругими волнами, лежит в основе динамич. фототермоупругости.

Достаточно полно разработано применение П.-о. м. для исследования сварочных напряжений. Т. к. методические способы исследования ведутся на прозрачных моделях, то всегда необходимо решать вопросы выбора параметров модели и перехода к соответствующим величинам натурального объекта (оригинала). Теория подобия в П.-о. м. достаточно хорошо разработана.

К П.-о. м. относится также метод оптически чувствительных покрытий, согласно к-рому на поверхность исследуемого объекта наносится тонкий слой оптически чувствительного материала. Деформация исследуемой поверхности будет полностью совпадать с деформациями покрытия, определение к-рых осуществляется П.-о. м. В этом случае применяются отражат. полярископы. Метод позволяет исследовать упруго-пластич. деформации, процессы разрушения и ползучести, деформации в микрообластях. Может использоваться не только в лабораториях, но и в промышленных и полевых условиях, на моделях и реальных конструкциях.

Дим. Александров, А. И. Ахметьянов, М. Х. Полляризационно-оптические методы механики деформируемого тела, М., 1973; Абен Х. К., Интегральная фототермоупругость, Тал., 1975; Метод фототермоупругости, т. 3, М., 1975; Материалы VIII Всесоюзной конференции по методу фототермоупругости, т. 1—4, Тал., 1978; Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений, К., 1981. В. И. Саченко, ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ — оптич. приборы для обнаружения, анализа, получения и преобразования поляризов. оптич. излучения, а также для разл. исследований и измерений, использующих явление поляризации света. К простейшим устройствам для получения и преобразования поляризов. света относятся поляризаторы (П.), фазовые пластинки (ФП), оптич. компенсаторы, деполаризаторы, оптич. стопы и др.

Процессы получения и преобразования поляризов. света основаны на взаимодействии света с веществом, нарушающих осевую симметрию светового луча. Для получения полностью или частично поляризованного света используется одно из трёх физ. явлений: поляризация при отражении или преломлении света на границе раздела двух изотропных сред с разл. показателями преломления, линейный дихроизм в двойном лучепреломлении. В первом случае анизотропия взаимодействия света со средой определяется наличием выделенной плоскости падения света и различием коэф. отражения для компонент светового луча, поляризованных параллельно и перпендикулярно этой плоскости (см. Френеля

формулы). При нормальном падении света на поверхность раздела (когда положение плоскости падения не определено) аксиальная симметрия взаимодействия света со средой не нарушается и поляризац. преобразования светового пучка не происходит. В соответствии с ф-лами Френеля степень поляризац. отраженной и преломленной компонент светового пучка зависит от угла падения. Если световой луч падает на границу раздела под углом Брюстера (см. Брюстера закон), то отраженный свет оказывается полностью поляризованным. На этом основано действие отражателей и х. П. Осн. недостаток отражат. П. — малость коэф. отражения — устраняется при использовании многослойных диалектр. покрытий (и в т е р е н ц и о н н ы е П.). Однако при этом сохраняются общие для всех отражат. П. недостатки — сильная зависимость степени поляризац. от угла падения (малая угл. апертура) и от длины волны света (хроматизм).

Луч, преломленный на границе раздела, поляризуется лишь частично, но при угле падения, равном углу Брюстера, компонента луча, поляризованная в плоскости падения, проходит через границу раздела без потерь. Т.о., пропуская свет последовательно через неск. прозрачных плоскопараллельных пластинок, можно достичь значит. степени поляризац. прошедшего пучка практически без ослабления интенсивности одной из поляризац. компонент (см. Стопа в оптике).

Аксиальная симметрия взаимодействия света со средой может нарушаться вследствие оптической анизотропии самой среды. При этом в области полос поглощения света оптически анизотропные среды неодинаково поглощают обыкновенный и необыкновенный лучи (линейных дихроизмов). При достаточной величине разности соответствующих оптч. плотностей одна из поляризац. компонент светового пучка может поглотиться практически полностью, и прошедший через среду свет приобретает высокую степень линейной поляризац. Такие П. наз. д и х р о и з м ы. Наиб. эффективными и практически единственными применяемыми в наст. время дихроичными П. являются *полярроиды*. Достоинствами полярроидов являются компактность, большая угл. апертура и высокая поляризующая способность, недостатками — низкая *лучевая прочность* и сильный хроматизм.

В области прозрачности для оптически анизотропных сред (кристаллов) характерно двойное лучепреломление, проявляющееся, в частности, в различии направлений групповых скоростей двух ортогонально поляризованных компонент распространяющегося по кристаллу светового луча. При пропускании узкого светового луча через соответствующим образом вырезанную пластинку оптически анизотропного кристалла на выходе из пластинки (при достаточной величине двулучепреломления) световой луч расщепится на два луча, линейно поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 1). Этот способ применяется для поляризац. узконаправленных пучков малого сечения (напр.,



излучение лазера) и требует использования материалов с высоким двулучепреломлением (типа исландского шпата). Более совершенными П., основанными на явлении двойного лучепреломления, служат *поляризац. призмы* (ПП), проходящие через к-рые две поляризац. компо-

ненты светового луча в общем случае не сохраняют направления распространения, отклоняясь на разл. углы. В однолучевых ПП одна из компонент луча испытывает *полное внутреннее отражение* на наклонной границе раздела составных частей призмы и обычно гасится её черной поверхностью. Вторая поляризац. компонента проходит через призму без изменения направления распространения. Двулучевые ПП расщепляют исходный световой пучок на два линейно поляризованных, распространяющихся в разл. направлениях. ПП характеризуются широким спектральным диапазоном рабочих частот, высокой поляризующей способностью и лучевой прочностью.

Циркулярные и эллиптические П. существенно отличаются от линейных из-за отсутствия сред с циркулярной или эллиптической анизотропией, сравнимой по величине с линейной. Обычно циркулярный П. представляет собой комбинацию последовательно расположенных линейно-и четвертьволновой ФП, выносящей фазовый сдвиг $\lambda/2$ между двумя ортогонально поляризованными компонентами световой волны и преобразующей линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный. Двулучепреломляющие ФП изготавливаются из материалов как с естественной, так и с индуцированной оптч. анизотропией; отражат. ФП (напр., ромб Френеля, рис. 2) — из оптически изотропных материалов, принцип их действия основан на изменении поляризац.

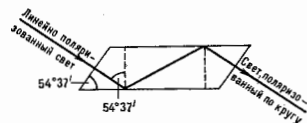


Рис. 2. Ромб Френеля. Значения углов указаны для отношения показателей преломления двух сред, равного 1,51.

состояния света при полном внутр. отражении. Пренуждением отражат. ФП перед двулучепреломляющими является слабая зависимость фазового сдвига от длины волны (хроматизм).

Все П. (линейные, циркулярные, эллиптические) могут использоваться и как *анализаторы*; при этом последовательно расположенные ФП и линейного П. в составных эллиптических и циркулярных П. инвертируются.

Деполаризация света обычно достигается не путём истинного устранения корреляции между его поляризац. компонентами (это практически невозможно), а путём получения излучения, к-рое в конкретных условиях данной задачи не проявляет своих поляризац. свойств. В качестве *деполяризаторов* для световых пучков широкого спектрального состава могут использоваться *силкохроматич. ФП*, создающие излучение со спектрально-осциллирующим состоянием поляризац. При измерениях с невысоким временным разрешением деполаризация может достигаться ВЧ-модулированной состоянием поляризац. пучка. При работе с широкими световыми пучками деполаризаторами могут служить *силкохроматич. ФП* переменной толщины (напр., клиновидные), создающие усредняющийся по всему сечению тонкий поляризац. рельеф светового пучка. В нек-рых случаях и в качестве линейного деполаризатора, устрояющего лишь линейную поляризац. анизотропию светового луча, может применяться циркулярный П., а в качестве циркулярного деполаризатора — линейный П.

Для поляризац. модуляции света обычно используются эффекты наведенной оптч. анизотропии (*Керра эффект*, *Поккельс эффект*, *Фарадей эффект*, *Дотюпурность*) в условиях модуляции вращ. возмущения (электрич. поля, магн. поля, деформации), примененного и оптч. среде. Возникающая при этом модуляция фазовых соотношений между поляризац. компонентами

светового пучка приводит к модуляции его поляризац. состояния при сохранении полной интенсивности. Поляризац. модуляторы служат основой для мн. модуляторов интенсивности света.

Приборы для поляризац.-оптич. исследований, несмотря на их многообразие, основаны на преобразовании поляризац. характеристик излучения в амплитудные. Любой фотоприёмник (в т. ч. и глаз) реагирует на интенсивность излучения, и конечным этапом поляризац. измерений является измерение интенсивности света. Простейшее преобразование поляризац. состояния света (заимствуя законы поляризац.) в интенсивностное описывается *Маллеса законом* и реализуется при пропускании линейно поляризованного излучения через линейный анализатор.

Среди сложных П. п. с визуальной регистрацией наиб. известен поляризац. о н я м и *микроскоп*, широко применяемый для определения величины и характера анизотропии кристаллич. сред и *жидких кристаллов*. Для изучения механич. напряжений в конструкциях используется поляризац.-оптич. метод исследования напряжений.

Для прецизионных измерений оптич. анизотропии с её зависимостью от длины волны служат автоматич. П. п. с фотоэлектрич. регистрацией. Количеств. анализ анизотропии сводится к сопоставлению оптич. свойств среды в двух ортогональных поляризац. путях поляризац. модуляции света. При измерении оптич. анизотропии, наведённой в среде внеш. возмущением, обычно модулируют это возмущение, и измерение сводится к регистрации противофазной модуляции интенсивностей двух поляризац. компонент пучка на частоте модуляции возмущения. Для повышения чувствительности измерений часто применяют баланс. схемы фоторегистрации (рис. 3). Две поляризац.

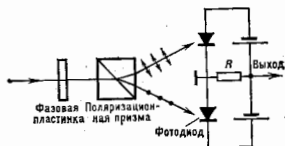


Рис. 3. Баланс.ная схема регистрации разности интенсивностей двух ортогонально поляризованных компонент светового луча.

компоненты пучка разделяются с помощью ФП и дуэльной (П) и поступают на два фотоприёмника, включённых так, что их фототоки на выходе схемы (нагрузке R) вычитаются. При этом регистрируемый сигнал противофазной модуляции интенсивностей компонент удваивается, а сфазиров. колебания интенсивности, связанные с флуктуациями интенсивности света, компенсируют друг друга, что значительно улучшает отношение сигнал/шум.

П. п. для измерений вращения плоскости поляризац. в средах с естественной или наведённой магн. полем оптич. активностью (*полариметры*) и дисперсии этого вращения (*спектрополариметры*) играют существенную роль в физ. исследованиях твёрдых тел, а также в хим. и биол. исследованиях. Применение в полариметрах лазерных источников света позволило достичь чувствительности к углу вращения плоскости поляризац. до $\sim 10^{-2}$ град.

Для обнаружения и количеств. определения поляризац. света используются *вольтметры*. Предельно обнаруживаемая примесь поляризов. света зависит от его интенсивности и практически достигает относит. значений $\sim 10^{-6}$.

П. п. широко применяются в науч. исследованиях электронной структуры атомов, молекул и твёрдых тел, а также в магн. свойствах разл. сред, поверхностных явлений и оптич. свойствах тонких плёнок (см. *Эллипсоидометры*), для регистрации статич. механич. напряжений; а также акустич. и ударных волн в прозрачных

средах, при изучении диффузии макромолекул в растворах, для определения содержания оптически активных молекул в растворах (см. *Сахариметрия*) и т. д. Принципы поляризац. оптики используются в приборах для геодезич. измерений, в системах *оптической локации* и *оптической связи*, в схемах управления лазерным излучением, в скоростной фото- и киносъёмке и пр.

Лит. см. при ст. *Поляризация света*.

В. С. Золотский.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПРИЗМЫ — один из классов *призм оптических*, простейшие поляризац. приборы, предназначенные для получения линейно поляризованного оптич. излучения (см. *Поляризация света*) или для определения характера и степени его поляризац. В соответствии с этим П. п. в оптич. приборах выполняют функции *поляризаторов* или *анализаторов*. Обычно П. п. являются дупреломляющими поляризаторами, т. е. поляризац. свет получается с использованием *двойного лучепреломления*. П. п. состоит из двух или более трёхгранных призм, на границе раздела между k -рых резко различаются условия прохождения для компонент светового луча, поляризованных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Такая ситуация реализуется, напр., при прохождении света через наклонную границу раздела двух сред, одна из k -рых сильно анизотропна. В качестве оптически анизотропных сред в П. п. используются прозрачные дупреломляющие кристаллы, наиб. употребительными из k -рых являются одноосный оптически отрицательный гексагональный кристалл исландского шпата (CaCO_3), обладающий широкой областью прозрачности и большим дупреломлением, кристаллич. кварц SiO_2 и фтористый магний MgF_2 .

Условия прохождения светового пучка через границу раздела между двумя средами обычно выбирают такими, что одна из поляризац. компонент испытывает *полное внутреннее отражение* и отсекается (поглощается червонной поверхностью призмы), а из призмы выходит только одна линейно поляризованная луч.

Трёхгранные призмы, изготавливаемые из оптически анизотропного материала, склеиваются прозрачным изотропным веществом, показателем преломления k -рого близок к ср. значению k -обыкновенного n_o и необыкновенного n_e лучей. Классич. примером такой П. п. является *призма Николя* (рис. 4), изобретённая в 1828 У. Николем (W. Nicol) и явившаяся первым эфф. линейным поляризатором, основанным на двойном лучепреломлении.



Рис. 4. Призма Николя. Штриховка указывает направление оптических осей кристалла в плоскости чертежа. Направления электрических колебаний световых волн указаны на лучах стрелками (колебания в плоскости рисунка) и точками (колебания перпендикулярны плоскости рисунка), о e — обыкновенный и необыкновенный лучи. Червонием нижней грани призмы поглощает полностью отраженный от плоскости склейки обыкновенный луч.

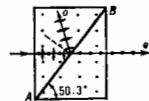
Существуют также П. п., элементы k -рых изготавливаются из оптически изотропного материала — стекла, а прослойка между ними — из кристалла исландского шпата. К этому типу П. п. относится *поляризатор Фюсснера*, изобретённый в 1884 (рис. 2).

При исследованиях в УФ-области спектра, а также при работе с мощными пучками оптич. излучения часто используются П. п., разделённые воздушными промежутками, — *призма Глана* (рис. 3), *призма Глана — Томсона* (рис. 4), *призма Фуко* (со скошенной входной и выходной граними, как

рис. 2. Поляризационная призма из стекла и исландского шпата (призма Фюссера). Точки в просвете шпата указывают, что его оптическая ось перпендикулярна плоскости рисунка.



рис. 3. Поляризационная призма Глана. AB — воздушный промежуток. Точки на обеих трехгранных призмах указывают, что их оптические оси перпендикулярны плоскости рисунка.



у призмы Николя) и пр. В П. п. со скошенными гранями проходящий луч испытывает параллельное смещение, поэтому при вращении призмы вокруг луча выходящий луч описывает окружность. От этого недостатка свободны П. п. в форме прямоугол. параллелепипедов: призмы Глана, Глана — Томпсона, Аренса (рис. 5), Глазбрука (половина призмы Аренса) и др.

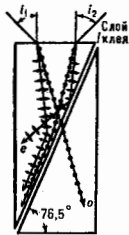


рис. 4. Предельные углы падения i_1 и i_2 лучей на поляризационную призму Глана — Томпсона.

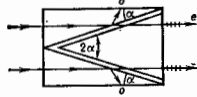


рис. 5. Поляризационная призма Аренса. Штриховой показан направление оптической оси.

Поляризующее действие призм, использующих полное внутр. отражение, зависит от угла падения светового луча: для сечетовых пучков, углы падения к-рых превышают нек-рые критич. значения i_1 и i_2 , условия разделения двух поляризац. компонент пучка не выполняются, и поляризующее действие призм прекращается (рис. 4). В общем случае $i_1 \neq i_2$, и угл. рабочее поле П. п. несимметрично. Сумма углов $i_1 + i_2$ наз. апертурой поляой поляризации П. п. и у нек-рой П. п. достигает 40° .

Наряду с описанными П. п., пропускающими один линейно поляризованный луч (т. е. однолучевые П. п.), существуют конструкции П. п., пространственно разделяющие две линейно поляризованные компоненты. Такие двулучевые П. п. широко применяются в разл. поляризац. приборах как своеобразные двухканальные анализаторы. Они используются для получения на выходе оптич. системы адекватного сигнала при нулевом методе измерений, а также для подавления избыточных световых шумов, проявляющихся в сплассовой модуляции интенсивности света в обоих каналах. Из двулучевых П. п. наиб. распространение имеют призмы Рошона, Сенармона и Волластова (рис. 6). В П. п. Рошона и Сенармона обыкновенный луч не ме-



рис. 6. Двулучевые поляризационные призмы: а — призма Рошона; б — призма Сенармона; в — призма Волластова. Штриховка указывает направление оптических осей кристаллов в плоскости рисунка.

няет своего направления, а необыкновенный отклоняется на угол θ ($5^\circ - 6^\circ$), зависящий от длины волны света. П. п. Волластова даёт при нормальном падении симметрич. отклонение обыкновенного и необыкновенного лучей.

Значит, распространение получили П. п., использующие поляризацию при отражении света. Они представляют собой прямоугол. параллелепипед из двух оптически изотропных трёхгранных призм с многоосными интерференц. покрытием на диагональной плоскости. Многоосльные диалектрич. покрытия (плёнки), создающие подложкающей комбинацией диалектрич. слоёв определ. толщины в разл. показателями преломления, дают т. в. интерференционные отраж. (коэф. отражения для определ. длин волн доходит до 98—99%). А т. к. при отражении происходит поляризация света, то плёнки, подобно оптич. стопе, дают сильно поляризованный отражённый свет. Такие интерференционные поляризаторы обладают значительной спектральной селективностью и зависимость степени поляризации от угла падения луча, но не требуют для своего изготовления дорогостоящих природных кристаллов исландского шпата и имеют довольно высокие поляризац. и угл. характеристики.

П. п. являются наиб. высококачеств. и универсальными поляризаторами для работы в широкой области спектра и в мощных пучках излучения.

Лит.: Шерклифф У., Поляризованный свет, пер. с англ., М., 1965; Крылова Т. Н., Интерференционные покрытия, Л., 1973. В. С. Залосский.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ в ядерных реакциях и при рассеянии элементарных частиц — зависимость сечения взаимодействия частиц от взаимной ориентации их спинов и импульсов. Зависимость взаимодействия заряд. частиц от ориентации их орбитального и спинового моментов хорошо известна в квантовой электродинамике. Воздействие магн. поля от орбитального движения электрона на его собств. магн. момент (спин-орбитальное взаимодействие) приводит к тонкому распределению ат. уровней (тонкая структура), а взаимодействие собств. магн. моментов ядра и электронов (спин-спиновое взаимодействие) наблюдается как сверхтонкое распределение, напр. различие уровней $^2S_{1/2}$ и $^4S_{3/2}$ в атоме водорода возникает из-за разл. магн. взаимодействия протона и электрона с параллельными и антипараллельными спинами (см. Сверхтонкая структура, Сверхтонкое взаимодействие). Аналогичные особенности присущи сильным взаимодействиям и слабым взаимодействиям.

Простейшим примером служит нерелятивистское рассеяние частицы со спином $s = 1/2$ (напр., нуклона) на бесспиновой частице, напр. на ядре с нулевым спином $I = 0$. Процесс рассеяния полностью описывается амплитудой рассеяния f , к-рая в данном случае является синовой матрицей $f_{\alpha\beta}$ ($\alpha, \beta = \pm 1/2$). Спин-орбитальное взаимодействие приводит к зависимости амплитуды рассеяния от спинов. При заданном (полученом) значении полного угл. момента системы l орбитальный момент может принимать 2 значения $l = j \pm 1/2$, отвечающие разл. четности. Поэтому на сохранении l и четности следует сохранить абс. значения l , т. е. оператора F . Единственным действующим на спины инвариантным оператором, коммутирующим с F , является оператор sl или пропорциональный ему оператор sv (v — единичный псевдовектор нормалн к плоскости рассеяния: $v \parallel [n]$), где n и n' — единичные векторы в направлениях падающего и рассеянного пучков). Поэтому общий вид оператора амплитуды рассеяния в рассматриваемом случае [1]:

$$\hat{f} = A + 2Bsv, \quad (1)$$

где амплитуды A и B не зависят от спинов. Дифференц. сечение рассеяния частицы $d\sigma_{\alpha\beta}/d\Omega$ из состояния α

проекции спина α в состоянии с проекцией спина β определяется величиной $|f_{\alpha\beta}|^2$. Обычно важно сечение рассеяния, просуммированное по конечным в усредненное по начальным проекциям спина. Для такой величины из (1) следует:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} |f_{\alpha\beta}|^2 = |A|^2 + |B|^2 + 2\text{Re}(AB^*)vP, \quad (2)$$

где псевдотор поляризации падающего пучка $P = 2s$ (s — ср. спин в нач. состоянии). Эта величина приобретает ясный смысл, если ось квантования направлена по v . Тогда

$$vP = \frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-}.$$

Здесь N_{\pm} — число частиц со спином по направлению v и против. Благодаря множителю vP в ф-ле (2) сечение рассеяния зависит не только от полярного угла θ , но и от азимутального угла ϕ между векторами v и m' . Поляризация рассеянных частиц может быть вычислена по ф-ле

$$P' = 2 \sum_{\alpha\beta} |f_{\alpha\beta}|^2 s_{\alpha\beta} v \sum_{\alpha\beta} |f_{\alpha\beta}|^2. \quad (3)$$

Для неполяризованного пучка ($P = 0$)

$$P' = \frac{2\text{Re}(AB^*)}{|A|^2 + |B|^2} v; \quad \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 = |A|^2 + |B|^2. \quad (4)$$

Т. о., из (2) получается

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 (1 + P P'). \quad (5)$$

Из (4) видно, что при наличии спин-орбитального взаимодействия ($B \neq 0$) неполяризов. пучок после рассеяния приобретает поляризацию, направленную перпендикулярно плоскости рассеяния.

Величину P' наз. анализирующей с способностью мишени A . Если поляризац. свойства ядер мишени известны, т. е. известно A , то, измеряя асимметрию, рассеяние налево и направо на этом ядре, можно определить степень поляризации пучка бомбардирующих частиц. В свою очередь пучки поляризова. частиц могут быть получены в результате рассеяния для ядерных реакций. Выражение (2) для рассеиваемых частиц со спином $1/2$ справедливо для мишени с произвольным спином, если она неполяризована.

В общем случае, когда спин рассеиваемой частицы больше $1/2$ или спин мишени отличен от 0, для описания поляризации пучка и анализирующей способности мишени требуется большее число параметров. В случае спина 1 возможны 3 значения проекции спина ($+1, 0, -1$), и для описания состояния пучка помимо поляризации необходимо знание выстроенности пучка по спину, т. е. величины

$$(N_+ + N_0 - 2N_-)/(N_+ + N_0 + N_-).$$

Поляризация рассеянных частиц в этом случае определяется не одной, как в случае $s = 1/2$, а двумя поляризующими способностями.

В случае, когда частицы пучка и мишени поляризованы, для описания эфф. сечения необходимо, кроме анализирующей способности, использовать т. н. коэф. корреляции c и v . Во время к-ой анализирующей способности описывают времяжизнность, рассеяния или ядерной реакции к состоянию поляризации пучка или мишени, коэф. корреляции описывают их чувствительность к параметрам, характеризующим корреляцию спинов пучка и мишени.

Все рассмотренные выше величины, характеризующие зависимость от спинов характеристик ядерной реакции, — поляризация продуктов реакции, анализиру-

ющая способность мишени, коэф. корреляции спинов — могут быть определены экспериментально. Их наз. поляризац. параметрами и наблюдаем. м. и. Измерение этих поляризац. наблюдаемых наз. поляризац. опытом.

Важный практич. случай — рассеяние двух нерелятивистских частиц со спинами $s_1 = s_2 = 1/2$, напр. нуклон-нуклонное (NN) рассеяние при небольших энергиях. В этом случае аналог разложения (1) оператора \hat{f} содержит 5 инвариантных амплитуд:

$$\hat{f} = A + B(s_1\lambda)(s_2\lambda) + C(s_1\mu)(s_2\mu) + D(s_1\nu)(s_2\nu) + E(v+s_1\nu). \quad (6)$$

Здесь единичные векторы λ, μ, ν направлены вдоль векторов $p + p', p - p', [m']$ соответственно. Амплитуды B, C, D наз. теоретич. E — спин-орбитальной. Дифференц. сечение рассеяния неполяризов. нуклонов определяется всего одной комбинацией этих амплитуд, а для вычисления их всех из эксперимента требуется проведение полного опыта.

NN-рассеяние при энергиях $E < 300$ МэВ обычно рассматривают в нерелятивистском приближении и описывают с помощью NN-потенциала, содержащего помимо центрального теоретич. и спин-орбитальный компоненты. Для определения этих компонентов требуется знание всех инвариантных амплитуд в разложении (6).

При описании рассеяния нуклонов в легких ядрах ядер не ядрах используют оптич. модель ядра с оптич. потенциалом, содержащим центральный и спин-орбитальный компоненты. С помощью эксперим. данных по дифференц. сечению $d\sigma/d\Omega$ и поляризации P' удается оценить форму и величину разл. членов оптич. потенциала.

Кроме выяснения характера спиновой зависимости нуклон-нуклонного и нуклон-ядерного взаимодействия, изучение П. о. позволяет уточнить информацию об уровнях ядер, установить механизм ядерных реакций, более полно осуществить проверку принципов симметрии в ядерных взаимодействиях (см. *Несохранение четности в ядрах*). Так, для установления степени несохранения четности в нуклон-нуклонном рассеянии была измерена продольная компонента анализирующей способности для p - p -рассеяния. Уровень несохранения четности оказался порядка 10^{-2} . При релятивистских энергиях взаимодействующих частиц для амплитуды реакции также можно записать разложение типа (1) или (6) по релятивистски инвариантным компонентам, для нахождения к-рых требуется проведение поляризац. экспериментов. Т. о., изучение П. о. является важным инструментом исследования фундам. свойств элементарных частиц, ядер и их взаимодействий.

Лит.: Ливингстон Л. Д., Диффизия Е. М., Бьюстайн Механика 4 изд. М., 1988; Немец О. Ф., Янгеновский А. М., Поляризац. исследования в ядерной физике, К., 1986; Данилов Л. И., Поляризац. явления в ядерных взаимодействиях при промежуточных энергиях, 374 ЯЯ, 1984, т. 15, в. с. 498; High-energy spin physics, 8-th Intern. sympos., Minneapolis, US, ed. by K. J. Heller, v. 1—2, Mn., 1988, 9. E. Coneruptum.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР в квантовой электродинамике — функция, представляющая собой аналог массовой оператора для безмассовой частицы — фотона. Включает вклады диаграмм поляризации вакуума в пропагатор фотона. Совокупность таких вкладов, простейший из к-рых отвечает первой диаграмме на рис. 1 в ст. *Поляризация вакуума* (также рассмотрен в ст. *Регуляризация расходимостей*), образует П. о. $\Pi_{\mu\nu}(k, a)$. Здесь k — 4-импульс фотона, $a = e^2/4\pi \approx 1/137$ — постоянная тонкой структуры, по стенкам к-рой располагаются вклады теории возмущений в П. о., μ, ν — Лоренцевы индексы, соответствующие разл. значениям поляризации фотона. После устранения расходимостей в соответствии с условием калибровочной инвариантности $\Pi_{\mu\nu}$ имеет порочную структуру:

$$\Pi_{\mu\nu}(k, a) = (g_{\mu\nu}k^2 - k_{\mu}k_{\nu})\pi(k^2, a),$$

где $\epsilon_{\omega\omega}$ — метрический тензор пространства-времени Минковского, а скалярная ф-ция $\pi(k^2, \alpha)$ входит в знаменатель поперечной части «детого» фотонного проп-гатора:

$$D_{\omega\nu}^0(k, \alpha) = \left(\epsilon_{\omega\omega} - \frac{k_\omega k_\nu}{k^2} \right) \frac{1}{k^2 - \pi(k^2, \alpha)}$$

Лит.: Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Квантовые поля, М., 1980, § 29.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ СВЕТОВЫЙ ФИЛЬТР — светофильтр, действие к-рого основано на явлении интерференции поляризов. лучей. Простейший П. с. представляет собой хроматич. фазовую пластинку (см. Компенсатор оптический), расположенную между двумя поляризаторами, поляризующие направления к-рых параллельны (перпендикулярны) друг другу и составляют угол 45° с оптич. осью пластинки. Т. к. фазовый сдвиг δ между обыкновенными (n_o) и необыкновенными (n_e) лучами, прошедшими через пластинку длиной l , зависит от длины волны λ ($\delta = 2\pi l(n_e - n_o)/\lambda$), то состояние поляризации, а следовательно и интенсивность выходящего света (см. Интерференция поляризованных лучей), также имеет спектральную зависимость. При достаточно большой разности показателей преломления фазовой пластинки ($n_e - n_o$) состояние поляризации выходящего из неё света может меняться в зависимости от λ от линейной, совпадающей с падающей, через все фазы эллиптической, до линейной, ортогональной исходной. Если поляризация света, прошедшего фазовую пластинку, совпадает с поляризующим направлением поляризатора на выходе, то наблюдается максимум в интенсивности выходящих интерферирующих поляризов. лучей; если соответствующие поляризации ортогональны, то наблюдается минимум. Таким образом, П. с. в зависимости от λ или полностью пропускает свет, или почти полностью поглощает. Это свойство П. с. используется для решения ряда спец. задач спектроскопии, напр. для подавления одной или нек-ск. спектральных линий излучения на фоне др. компонент спектра или для изменения спектрального распределения энергии в источниках сплошного спектра.

Селективные П. с. пропускают получение тонкой в узком спектральном интервале. К ним относятся изобретённый в 1933 В. Лью (В. Lyot) П. с., представляющий собой последовательность к-х поляризаторов (с идентично ориентированными поляризующими направлениями) и расположенных между ними ($k-1$) фазовых пластин. Каждая последоват. тройка элементов (поляризатор — фазовая пластинка — поляризатор) представляет собой простейший описанный выше П. с. Толщина первой фазовой пластинки выбирается такой, чтобы обеспечить полное пропускание первой тройки элементов фильтра. Лью на заданной длине волны λ_0 (т. е. фазовый сдвиг кратен 2π). Толщина каждой следующей пластинки точно вдвое превышает толщину предыдущей, сохраняя, т. о., указанную кратность фазового сдвига на длине волны λ_0 . В результате все компоненты фильтра обеспечивают полное пропускание на длине волны λ_0 , тогда как на остальных участках спектра по мере роста числа пластин пропускание всё в большей степени подавляется. Практически таким способом удаётся создать П. с. со спектральной шириной полос пропускания до 10^{-2} нм. Недостатки П. с. Лью — малая угл. рабочая апертура и сильная температурная зависимость спектральных характеристик, что приводит к необходимости тщательной термостабилизации всего устройства.

К узкополосным П. с. относится также изобретённый в 1955 И. Шолком (I. Solo) фильтр, представляющий собой расположенный между двумя линейными поляризаторами набор из большого числа фазовых пластинок, оси анизотропии к-рых последовательно перпендикулярны одна относительно другой на малый угол. П. с. Шолка обладает значительно более высоким пропусканием,

чем П. с. Лью, но значительно уступает последнему по качеству спектральной селективности.

П. с. представляют собой сложные оптич. системы, очень чувствительные к температурным и др. внешним воздействиям, поэтому их применение ограничено; они используются гл. обр. в астрофиз. исследованиях.

Лит.: Шерккифф У., Поляризованный свет, пер. с англ., М., 1985.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ансамбля частей α — преимущественная ориентация спинов частиц. Пусть в ансамбле частиц со спином $s = 1/2$ задана ось квантования z , т. е. задано направление в пространстве, на к-рое частицы имеют определённые проекции спина $m = \pm 1/2$. Обычно по оси z направлено внешнее, напр. магн., поле, к-рое и формирует спиновую упорядоченность ансамбля. Если заданы вероятности W_+ , W_- нахождения частиц на уровнях с проекциями спина $m = \pm 1/2$, то поляризация ансамбля $\mathcal{P} = W_+ - W_-$; $-1 \leq \mathcal{P} \leq 1$; \mathcal{P} — параметр, полностью характеризующий спиновое состояние ансамбля. Для случаев спина $s = 1$ имеются три состояния $m = +1, 0, -1$ и три вероятности W_+, W_-, W_0 . Наряду с поляризацией $\mathcal{P} = W_+ - W_-$ существует ещё один параметр $T = 1 - 3W_0 = W_+ + W_- - 2W_0$, наз. выстроенностью. Для описания ансамбля частиц с более высоким спином потребуются большее кол-во независимых параметров (см. также Ориентированные ядра, Поляризованные нейтроны).

ПОЛЯРИЗАЦИЯ среды — процесс, в результате к-рого физ. объект (атом, молекула, твёрдое тело и др.) приобретает элетрич. дипольный момент P . П. может возникать под действием элетрич. поля E , упругой деформации и (пьезоэлектрич. эффект), изменения темп-ры δT (пироэлектрич. эффект), магн. поля H (магн.-электрич. эффект), градиента деформации du/dx (флексозэлектрич. эффект) и др., градиента темп-ры $\delta T/\delta x$ (термополяризац. эффект) и др.

2) Вектор P , связывающий элетрич. поле E с элетрич. индукцией D :

$$D = E + 4\pi P \text{ (СГС); } D = E + P \text{ (СИ).}$$

По определению, $\text{div} P = -\rho_{\text{вн}}$, $P = 0$ вне тела, где $\rho_{\text{вн}}$ — усреднённая (по объёму много больше, чем атомные размеры) плотность связанных зарядов диэлектрика.

Связь между локальными значениями P и факторами, приводящими к её возникновению, записывается в виде

$$P_i = \chi_{ij} E_j + \lambda_{ijl} u_{jl} + p_i \delta T + d_{ij} H_j + f_{ijl} \frac{\partial u_k}{\partial x_l} + b_{ij} \frac{\partial T}{\partial x_l} \quad (*)$$

Здесь χ — диэлектрическая восприимчивость, λ — пьезоэлектрич. коэф. (см. Пьезоэлектрики), p — пироэлектрич. коэф. (см. Пироэлектрики) и т. д. Линейная связь между P и величинами $u, \delta T, H$ возможна лишь в средах с опред. кристаллич. и магн. симметрией. Среднее (по объёму тела) значение P равно отношению дипольного момента тела к его объёму. Для тела макроскопич. размеров связь ср. P со ср. значениями $E, du/dx, \delta T$ и H определяется объёмными свойствами материала и задётся локальными соотношениями (*), тогда как связь со ср. значениями градиентов деформации и темп-ры может существенно зависеть от свойств поверхности тела.

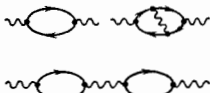
Лит.: Ашкрофт М. Мермин Н. Физика твёрдого тела, пер. с англ., т. 2, М., 1978; Гроот С. Р. де, Сатторп Л. Г., Электродинамика, пер. с англ., М., 1982; Таганцев А. К., Пиро-, пьезо-, флексозэлектрический и термополяризованный эффекты в ионных кристаллах, УФН, 1967, т. 152, в. 3, с. 423.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВАКУУМА в физике частиц — совокупность виртуальных процессов, аналогичных нулевым колебаниям квантовой механики, характе-

ризующих нижнее, вакуумное, состояние системы взаимодействующих квантовых полей.

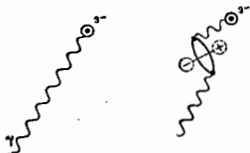
Первоначально термин «П. в.» возник в квантовой электродинамике (КЭД) и в узком смысле ассоциируется с процессами виртуального превращения фотона в пару e^+e^- с последующей рекомбинацией (рис. 1). Такие

Рис. 1. Диаграммы поляризации вакуума в квантовой электродинамике.



виртуальные переходы в буквальном смысле слова ответственны за поляризацию «пустоты» в окрестности любого заряда. Рассмотрим их влияние на процесс измерения заряда электрона. Такое измерение реализуется внеш. эл.-магн. полем. На рис. 2 (слева) изображена классич. картина, не учитывающая П. в.; правый рис. описывает ситуацию, когда фотон-пробник

Рис. 2. Диаграммы, изображающие процесс измерения заряда электрона (обозначено символом e^-) внешним полем.



диссоциирует на электрон и позитрон, к-рые образуют виртуальный диполь, эквивалентный поляризации материальной среды. Описанный механизм приводит к возникновению *эффектного заряда* в КЭД.

В совр. литературе термин «П. в.» обозначают широкий круг виртуальных переходов, обусловленных вакуумными флуктуациями, напр. процесс «соединения» цветного кварка, рождённого в глубоко неупругом рассеянии, в результате к-рого он превращается в бесцветный адрон или струю адронов. Д. В. Ширков. **ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОЛН** — характеристика волны, определяющая пространственную направленность векторных волновых полей. Исторически это понятие было введено в оптике ещё во времена «доклассических описаний» и первоначально основывалось на свойствах поперечной аннизотропии волновых пучков (см. *Поляризация света*). Оно распространено на все без исключения типы физ. волновых возмущений (см. *Волны*), но осн. терминология по-прежнему осталась связанной с эл.-магн. (в частности, оптическим) полями.

Различают продольно и поперечно поляризованные волны в зависимости от ориентации вектора поля относительно волнового вектора (\mathbf{k}). В электродинамике примером продольных волн служат плоские однородные плазменные волны (см. *Слабоинерционные волны*); к поперечным волнам в первую очередь относятся плоские однородные эл.-магн. волны в вакууме или в однородных изотропных средах. Поскольку в последних векторы (\mathbf{E}) и магн. (\mathbf{H}) векторы перпендикулярны волновому вектору (\mathbf{k}), то их часто наз. волнами типа *ТЕМ* или *ТЕН* (см. *Волновод*). Причём, если векторы поля (\mathbf{E} , \mathbf{H}) лежат в фиксиров. плоскостях (\mathbf{E} , \mathbf{k}) и (\mathbf{H} , \mathbf{k}), т. е. имеют фиксиров. направления в пространстве, используют термин «волны линейной поляризации». Суперпозиция двух линейно поляризованных волн, распространяющихся в одном направлении (\mathbf{k}) и имеющих одинаковую частоту (ω), но отличающихся направлением векторных полей, даёт в общем случае волну эллиптической поляризации. В век концы векторов \mathbf{E} и \mathbf{H} описывают в плоскости,

перпендикулярной \mathbf{k} , эллиптич. траектории, ориентированные по правому или по левому вилу в направлении \mathbf{k} в зависимости от знака и величины разности фаз ($\Delta\phi$) между исходными линейно поляризованными составляющими. Соответственно, такая волна наз. право- или левополяризованной, что не совпадает с терминологией, принятой в оптике, где отсчёт направления вращения вектора поля ведётся в направлении $(-\mathbf{k})$, т. е. в направлении на источник. В частном случае вырождения эллипсов в окружности волны становятся циркулярно поляризованными. Иногда именно волны с циркулярной (круговой) поляризацией выбирают в качестве нормальных мод среды. Линейно, эллиптически и циркулярно поляризованные волны являются полностью поляризованными волнами. Неполностью. волны имеют в отличие от них некоррелированные во времени случайное направление векторов полей (\mathbf{E} и \mathbf{H}) (в оптике — естественный свет). Когда в волновом поле наряду со случайной присутствует ещё и поляризов. составляющая, то говорят о частично поляризованных волнах, количество характеризуемых степенью поляризации, равной отношению средней по времени интенсивности поляризованной части излучения к полной её значению (см. *Коэрентность*).

Весма сложными поляризац. свойствами обладают пространственно неоднородные волны, к-рые в принципе можно рассматривать как суперпозицию однородных плоских волн (см. *Волновод*). При этом характер поляризации векторов \mathbf{E} и \mathbf{H} часто оказывается различным. Так, если в бегущих вдоль оси z волнах типа *ТМ* поле \mathbf{H} ориентировано в поперечной к \mathbf{k} плоскости ($\mathbf{H} \perp \mathbf{k}$), а поле \mathbf{E} образует эллипс поляризации в плоскости (\mathbf{E} , \mathbf{k}), то в волнах типа *ТЕ* данное свойство видоизменяется ($\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$, $\mathbf{H} \rightarrow -\mathbf{E}$). Для част. стоячих волн приходится всегда указывать, относительно какого направления ориентированы эллипсы поляризации.

В неоднородных средах, как правило, описать поляризацию волновых полей очень трудно. Обычно ограничиваются рассмотрением лишь случая кусочно-однородных сред, в частности задача о падении плоской волны на резкую границу раздела двух однородных изотропных сред (см. *Френеля формулы*).

В аннизотропных средах разной поляризации имеют разл. скорости распространения и разл. коэф. затухания. Поэтому при падении волн на границу раздела с аннизотропной средой могут возникать сразу нек. преломлённых волн, распространяющихся под углами, отличными от устанавливаемых *Снелла законами*. Такие свойства аннизотропных сред лежат в основе многих *поляризационных приборов* (разл. поляризаторов, деполаризаторов, поляризац. анализаторов, комплементаров и т. п.).

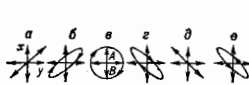
Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Григубург В. Л., Распространение электромагнитных волн в плазме, 2 изд., М., 1987; Бора М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Л. А. Жерар, А. И. Соколов.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА — ф-за характеристика оптич. излучения, описывающая поперечную аннизотропию световых волн, т. е. неэквивалентность разл. направлений в плоскости, перпендикулярной световому лучу. Первые указания на поперечную аннизотропию светового луча были получены в 1690 Х. Гюйгенсом (Ch. Huygens) при опытах с кристаллами исландского шпата. Понятие «П. с.» введено в оптику в 1704—08 И. Ньютоном (I. Newton). Существ. значение для понимания П. с. имело её проявление в эффектах *интерференции света* и, в частности, тот факт, что два световых луча с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации непосредственно не интерферируют. П. с. нашла естеств. объяснение в эл.-магн. теории света, разработанной в 1865—73 Дж. К. Максвеллом (J. C. Maxwell), позднее — в квантовой электродинамике.

Поперечно эл.-магн. волны имеют ещё осевой симметрии относительно направления её распространения из-за наличия выделенных направлений (вектора \mathbf{E} —

напряженности электрич. поля, вектора \mathbf{H} — напряженности магн. поля) в плоскости, перпендикулярной направлению волнового вектора. Состояние П. с. принято связывать с типом движения вектора \mathbf{E} , направленного к-рому в нерелятивистском приближении определяет направление силы, действующей на заряд. частицу в поле световой волны. Полностью поляризованная световая волна характеризуется полной скоррелированностью (когерентностью) колебаний взаимно ортогональных компонент вектора \mathbf{E} , т. е. постоянством их амплитуд и разности фаз. Все типы П. с. можно рассмотреть на примере монохроматич. эл.-магн. волны, компоненты вектора \mathbf{E} n -ой меняются во времени по гармонич. закону, а сам вектор \mathbf{E} совершает неизменно воспроизводимое периодич. движение. Монохроматич. волна, очевидно, всегда полностью поляризована. Графически состояние П. с. обычно изображают с помощью эллипса поляризации — проекция траектория вектора \mathbf{E} на плоскость, перпендикулярную лучу (рис. 1). Проекц. картина полностью поляризованного света в общем случае имеет вид эллипса с правым или левым направлением вращения вектора \mathbf{E} (рис. 1, б, г, е). Такой свет наз. эллиптически поляризованным. Наиб. интерес представляют предельные случаи эллиптич. поляризации — линейная, когда эллипс поляризации вырождается в отрезок прямой линии (рис. 1, а, в), определяющий положение (азимут

Рис. 1. Примеры различных поляризованных состояний светового луча при различных разностях фаз между равными взаимно ортогональными компонентами E_x и E_y .



в) плоскости поляризации, и циркулярная (или круговая), когда эллипс поляризации представляет собой окружность (рис. 1, в). В первом случае свет наз. плоскополяризованным или линейно поляризованным, а во втором — право- или левоциркулярно поляризованным в зависимости от направления обхода эллипса поляризации. П. с. принято называть правой, если вектор \mathbf{E} совершает вращение по часовой стрелке при наблюдении навстречу световому лучу.

Для количеств. описания характера поляризации полностью поляризованного света используют величину отношения длин малой (B) и большой (A) полуосей эллипса поляризации — эллиптичности $e = B/A$, приписывая ей знак, определяемый направлением вращения вектора \mathbf{E} . Правополяризованному свету приписывают положительную эллиптичность, а левополяризованному свету — отрицательную. Т. о., для всех типов П. с. эллиптичности e лежит в пределах $-1 \leq e \leq 1$. В нек-рых случаях удобно ввести также угол эллиптичности ϵ , определяемый соотношением $e = \arctg \epsilon$, ($-\pi/4 \leq \epsilon \leq \pi/4$).

При аналитич. описании П. с. обычно не рассматривают временные и пространственные изменения эл.-магн. волны. Наиб. простое аналитич. описание полностью эллиптич. поляризованного света осуществляется с помощью в вектора Д ж о н с а, представляющего собой столбец из двух величин, определяющих комплексные амплитуды ортогональных компонент волны в данной точке пространства:

$$\begin{bmatrix} E_x \exp i \delta_x \\ E_y \exp i \delta_y \end{bmatrix}$$

Здесь E_x и E_y — скалярные амплитуды гармонич. колебаний вектора \mathbf{E} вдоль осей x и y , а δ_x и δ_y — их фазы. Точное представление поляризов. света удобно при решении задач преобразования П. с., взаимодействующего с разл. недеполяризуемыми оптическ. анзотропными элементами (см. Д ж о н с а матричный метод). В тех случаях, когда конкретные величины амплитуд и фаз компонент волны не важны, сведения о форме эллипса поляризации можно получить из комплексной величины, определяемой как отношение компонент вектора Д ж о н с а:

$$\chi = E_y \exp i \delta_y / E_x \exp i \delta_x = (E_y / E_x) \exp i (\delta_y - \delta_x)$$

При этом модуль χ определяет отношение амплитуд компонент вектора \mathbf{E} , а аргумент — разность фаз этих компонент. Т. о., между разл. типами П. с. и точками комплексной плоскости существует однозначное взаимное соответствие, что позволяет рассматривать комплексную плоскость как пространство состояний в П. с. Связь между комплексной величиной χ и параметрами эллипса поляризации (азимут θ и углом эллиптичности ϵ) дается выражением

$$\chi = (tg \theta + i t g \epsilon) / (1 - i t g \theta t g \epsilon)$$

На рис. 2 изображены состояния П. с., соответствующие разл. точкам комплексной плоскости $\chi_r + i \chi_i$. Состояния поляризации, характеризующиеся постоянной разностью фаз между E_x и E_y , располагаются

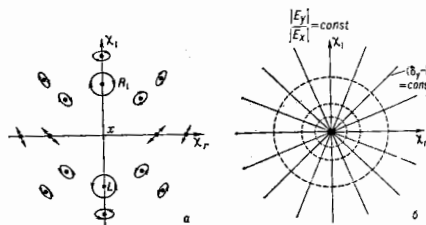


Рис. 2. Состояния поляризации, соответствующие различным точкам декартовой комплексной плоскости. Начало координат ($\chi = 0$) и бесконечно удаленная точка ($\chi = \infty$) соответствуют базисным состояниям горизонтальной и вертикальной линейной поляризации. Все состояния линейной поляризации с произвольным азимутом плоскости поляризации располагаются на вещественной оси χ_r . Точки R ($\chi = i$) и L ($\chi = -i$) соответствуют правой и левой круговым поляризациям.

на этой плоскости вдоль радиальных прямых, проходящих через начало координат, а состояния с одинаковым отношением амплитуд E_y/E_x — вдоль concentric. окружностей с центром в начале координат.

Состояния П. с. можно представить не только в декартовой комплексной плоскости. В качестве базисных состояний вектора Д ж о н с а может использоваться любая пара взаимно ортогональных состояний поляризации, т. е. состояний с азимутами эллипсов поляризации θ , отличающимися на $\pi/2$, и углами эллиптичности ϵ , равным модулю, но имеющими противоположные знаки. В частности, используя состояния циркулярной поляризации в качестве базисных, можно установить соответствие между типами П. с. и точками комплексной плоскости на базе соотношения $\chi = (E_r/E_l) \exp i (\delta_r - \delta_l)$, где E_r и E_l — амплитуды право- и левоциркулярно поляризованных компонент световой волны, а $(\delta_r - \delta_l)$ — разность фаз между ними. В этом случае начало координат и бесконечно удаленная точка комплексной плоскости соответствуют состояниям циркулярной поляризации, а точки, расположенные по окружности единичного радиуса с центром в начале координат, — состояниям линейной поляризации. Это представление особо интересно потому, что в 1892 А. Пуанкаре (Н. Poincaré), используя стереографич. проекционное преобразование, установил однозначную связь между точками декартовой комплексной плоскости П. с. с циркулярными базисными состояниями и точками сферы. Поверхности состояний поляризации, названных впоследствии Пуанкаре сферой. Сфера Пуанкаре явля-

ется наиб. компактным геом. представлением пространства П. с. и широко используется при решении задач доп. оптики.

Состояние П. с. немонохроматической световой волны, как правило, не может быть описано вектором Джонса или точкой на сфере Пуанкаре, т. к. компоненты вектора E немонохроматич. волны не полностью скоррелированы. Поэтому компоненты вектора Джонса оказываются зависящими от времени с характеристич. временем корреляции, равной примерно обратной ширине спектра (для световых полей широкого спектрального состава понятие вектора Джонса вообще теряет смысл). В результате разность фаз и отношение амплитуд компонент вектора E меняются за время, обычно существенно более короткое, чем время измерения состояния поляризации, и свет является в этом случае частично поляризованным. Если к-л. корреляция между значениями амплитуд и фаз компонент вектора E отсутствует, свет не обнаруживает анизотропии в плоскости колебаний вектора E и наз. неполяризованным или естественным.

Для аналитич. описания поляризац. состояния немонохроматич. световых волн используют параметры, отражающие усредненные по времени интенсивности раал. поляризац. компонент световой волны. В 1852 Дж. Стокс (J. Stokes) ввел вектор (см. Стокса параметры), представляющий собой совокупность четырех параметров (S_0, S_1, S_2, S_3), определяющих интенсивности соответств. всего пучка — S_0 , части пучка преи. с горизонтальной поляризац. — S_1 , с поляризац. под углом 45° — S_2 , с поляризац. правой циркулярной — S_3 . Благодаря простоте эксперим. определения параметров Стокса произвольным образом поляризованного света и удобству аналитич. описания процессов преобразования поляризации света с помощью Мюллера матрицы вектор Стокса широко используется при решении задач поляризац. оптики. Для полностью поляризованной световой волны компоненты вектора Стокса связаны соотношением $S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$. Для частично поляризованного света вводится понятие степени поляризации \mathcal{P} , определяемой как отношение интенсивности полностью поляризованной компоненты волны к её полной интенсивности:

$$\mathcal{P} = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2} / S_0, \quad (0 \leq \mathcal{P} \leq 1).$$

Сфера единичного радиуса, соответствующая всем состояниям полностью поляризованного света ($\mathcal{P} = 1$), совпадает со сферой Пуанкаре, а все точки внутри этой сферы соответствуют состояниям частичной поляризации.

Компоненты вектора Стокса связаны линейно с матрицей когерентности к-л. компоненты кривой в линейной форме описывают корреляц. свойства компонент волн:

$$I = \begin{pmatrix} \langle E_x E_x^* \rangle & \langle E_x E_y^* \rangle \\ \langle E_y E_x^* \rangle & \langle E_y E_y^* \rangle \end{pmatrix}.$$

Матрица когерентности в сочетании с матрицами Джонса служит для описания преобразования частично поляризованного света, распространяющегося через линейную недеполяризирующую среду. Для описания распространения света через деполаризующие среды используются матрицы Мюллера.

В квантовой электродинамике с П. с. связывают спиновое состояние фотонов, образующих световой пучок. Так, право- или левоциркулярно поляризованный свет соответствует потоку фотонов с проекцией спина на направление распространения (спиральность) $+1$ или -1 . Эллиптически поляризованному свету соответствует суперпозиция спиновых состояний эл.-магн. поля

(см. Интерференция состояний). Каждый ф. циркулярно поляризованных фотонов несёт момент импульса, равный $\pm \hbar$, что проявляется как в классических, так и в квантовых эффектах взаимодействия света с веществом (напр., в Садосковской эффекте).

Особенности элементарного акта излучения, а также множество физ. процессов, нарушающих осевую симметрию светового пучка, приводят к тому, что свет всегда частично поляризован. П. с. может возникать при отражении и преломлении света на границе раздела двух изотропных сред с разл. показателями преломления в результате разл. оптич. характеристик границы для компонент, поляризованных параллельно и перпендикулярно плоскости падения (см. Френеля формулы). Свет может поляризоваться либо при прохождении через анизотропную среду (с естеств. или индуцированной оптич. анизотропией), либо вследствие разн. коэф. поглощения для раал. поляризац. (см. Дихроизм), либо вследствие двойного лучепреломления. П. с. возникает при рассеянии света, при оптич. возбуждении резонансного сечения в парах, жидкостях и твёрдых телах. Обычно полностью поляризовано излучение лазеров. В сильных электрич. и магн. полях наблюдается полная поляризация компонент расщепления спектральных линий поглощения и люминесценции газообразных и конденсиров. сред (см. Электр. оптика, Магнит. оптика).

Нек-рые из этих эффектов лежат в основе простейших поляризац. приборов — поляризаторов, фазовых пластин, компенсаторов оптич. систем, деполаризаторов и т. д., с помощью к-рых осуществляется создание, преобразование и анализ состояния П. с. Изменение состояния П. с. в результате прохождения через двупреломляющую среду лежит в основе изучения оптич. анизотропии кристаллов. При визуальных исследованиях оптич. анизотропных сред используется эффект хроматич. поляризац. — окрашивания поляризов. пучка белого света в результате прохождения через анизотропный кристалл и анализатор.

Поляризов. свет служит не только как зонд оптич. анизотропии среды, но и как возмущение, индуцирующее анизотропию. Большинство такого рода эффектов относится к нелинейной оптике. Вне зависимости от механизма эффекта характер оптич. индуцируемой анизотропии определяется типом П. с. Так, циркулярно поляризованный свет способен индуцировать в среде циркулярную анизотропию и, в частности, вызвать появление аксиального вектора намагниченности (см., напр., Оптич. скважность ориентация), а линейно поляризованный свет индуцирует линейную анизотропию (экстракция, оптич. эффект Керра).

П. с. и особенности взаимодействия поляризов. света с веществом широко применяются в исследованиях кристаллохим. и магн. структуры твёрдых тел, оптич. свойств кристаллов, природы состояний, ответственных за оптич. переходы, структуры биол. объектов, характера поведения газообразных, жидких и твёрдых тел в полях анизотропных возмущений, а также для получения информации о труднодоступных объектах (напр., в астрофизике). Поляризов. свет используется во мн. областях техники: для плавкой регул. инт. интенсивности светового пучка, при исследовании напряжений в прозрачных средах (поляризационно-оптич. метод), при создании светофильтров, модуляторов излучения и пр.

Лит.: Ахмедов А. И., Берестецкий В. Б., Квантовая электродинамика. 4 изд., М., 1981; Феофило в П. П., Поляризованный люминесцентный атом, молекулы и кристаллы, М., 1989; Шеридан Ф. У., Поляризованный свет, пер. с англ., М., 1965; Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Джеррард А., Берр П. И., М., Введение в матричную оптику, пер. с англ., М., 1978; Азван Р., Башарв Н., Эллипсометрия и поляризованный свет, пер. с англ., М., 1981. В. С. Залаский.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ — характеристика состояния частиц, связанная с наличием у них собств. момента импульса — спина и его направлением в прост-

ранстве. Понятие поляризации света связано с поляризацией «частиц света» — фотонах.

Частица с ненулевой массой покоя (электрон, ядро и др.) и спином S (в единицах \hbar) имеет $2S + 1$ квантовых состояний, отвечающих разл. значениям проекции спина на нек-рое направление. Состояние частицы представляет собой суперпозицию этих состояний. Если коэф. суперпозиции (см. *Суперпозиции состояний принцип*) полностью определены (чистое состояние), то говорят, что частица полностью поляризована. Если коэф. суперпозиции определены не полностью, а заданы только нек-рыми статистич. характеристиками (*смешанное состояние*), то говорят о частичной поляризации. В частности, частица может быть полностью неполяризованной, это означает, что её свойства одинаковы по всем направлениям, как у частицы с $S = 0$. В общем случае П. ч. определяет степень симметрии (или асимметрии) свойств частицы в пространстве. Частица наз. поляризованной, если характеристика её симметрии включает витую ось (как у вращающегося твёрдого тела или у циркулярно поляризованного света; см. *Выстраивание*). Если такой оси нет, но нет и сферич. симметрии, то говорят о выстроенности (пример — линейно поляризованный свет). П. ч. определяется в общем случае числом параметров, равным $(2S + 1)^2 - 1$. Частица с нулевой массой покоя, напр. фотон, обладает только двумя состояниями, определяемыми спином, а её поляризация в общем случае определяется тремя параметрами. В. Б. Берестецкий.

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. Люминесцентное излучение мн. объектов полностью или частично, линейно или циркулярно поляризовано вследствие анизотропии элементарных актов поглощения и испускания квантов света в процессе люминесценции. Если люминесцирующая среда макроскопически анизотропна, то излучатели (атомы, молекулы, ионы) имеют преимущество, ориентацию моментов, к-рая и определяет поляризацию люминесценции. Анизотропия в среде может быть и мавелдиной, возникающей в результате направленной ориентации излучателей во внеш. поле (электрическом, магнитном), а также анизотропия возбуждения (в частности, при возбуждении люминесценции поляризов. светом).

Количественно П. л. характеризуются степенью поляризации

$$\rho = \frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{I_{\parallel} + I_{\perp}}$$

или степенью анизотропии

$$r = \frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{I_{\parallel} + 2I_{\perp}} = \frac{2\rho}{3 - \rho},$$

где I_{\parallel} и I_{\perp} — интенсивности взаимно перпендикулярных поляризов. компонент люминесценции. В случае анизотропных сред они соответствуют макс. и мин. компонентам, в случае изотропных — параллельно и перпендикулярно поляризованному по отношению к вектору напряжённости возбуждающего электрич. поля компонентам. Для линейно поляризованного света $\rho = r = -1$, для неполяризованного $\rho = r = 0$, для промежуточных случаев $\rho \neq r$. Величина r является отношением интенсивности поляризов. части излучения к полной интенсивности, учитывающей все три поляризованные компоненты, поэтому r обладает аддитивностью ($r = \sum_i r_i I_i / \sum_i I_i$, I_i — интенсивность люминесценции с анизотропией r_i), что часто удобно для расчётов.

Исследования П. л. позволяют получить информацию о строении и структуре элементарных излучателей — атомов и молекул вещества в разл. агрегатных состояниях, о взаимодействиях излучателей между собой и с окружающей средой.

П. л. атомных и молекулярных паров. Поляризов. излучение при линейно поляризов. возбуждении атом-

ружено в парах ртути и др. атомов, а также двухатомных может иметь объяснение, аналогичное объяснению *Зеемана эффекта*. Для двухатомных молекул возможно классич. рассмотрение возбуждённых молекул как линейных *осцилляторов*, колеблющихся вдоль оси молекулы.

Парь свободных сложных многоатомных молекул является изотропной средой, поэтому поляризация их люминесценции возможна только при анизотропном возбуждении. П. л. таких паров можно объяснить, рассматривая молекулы как набор классич. линейных осцилляторов, жёстко ориентированных относительно осей молекулы. Наиб. высокая степень поляризации люминесценции наблюдается для молекул, момент излучательного перехода к-рых направлен вдоль длинной оси молекулы. В этом случае эксперим. данные удовлетворительно описываются теорией с учётом ориентат. релаксации ансамбля жёстких симметричных и асимметричных вольтов (см. *Молекула*) в условиях свободного вращения. Теоретич. и эксперим. данные лучше всего совпадают для переходов с большой силой осциллятора. Расхождение теории и эксперимента для др. случаев объясняется суперпозицией ортогональных осцилляторов — «заимствованием» поляризации в результате электронно-колебат. взаимодействия, индуцируемого неполюсимметрич. колебаниями. Изучение временной кинетики поляризации флуоресценции разреженных паров сложных многоатомных молекул — эфф. метод исследования вращат. релаксации этих молекул.

П. л. паров сложных молекул может быть создана не только при возбуждении линейно поляризованным светом, но и при возбуждении пучком быстрых электронов. В этом случае роль анизотропного фактора возбуждения играет вектор импульса падающего и рассеянного электронов (при возбуждении поляризов. светом эту роль выполняет вектор напряжённости E электрич. поля поляризованной эл.-магн. волны). Для коллинейных q и E и при одинаковых энергиях возбуждения степень поляризации флуоресценции в обоих случаях должна совпадать, что и подтверждается экспериментально.

П. л. изотропных растворов сложных молекул также описывается с помощью осцилляторных моделей. Это вид П. л. особенно равномерно исследован. Люминесценция растворов может быть поляризована не только при возбуждении линейно поляризованным светом (степень поляризации ρ_p), но и при возбуждении естественным, неполяризованным светом и наблюдении люминесценции в направлении, перпендикулярном лучу возбуждения (ρ_n), причём $\rho_n = \rho_p(2 - \rho_p)$. Осцилляторная модель позволяет рассчитать предельные значения поляризации: $\rho_p = 1/2$ для случая, когда осцилляторы поглощения и испускания совпадают по направлению, и $\rho_p = -1/3$ для случая, когда они взаимно перпендикулярны.

Реально наблюдаемые значения степени поляризации, как правило, меньше теоретических, что обусловлено разл. процессами деполаризации, важнейшие из к-рых — вращательная и концентративная. Уменьшение ρ в результате вращат. диффузии может быть частично компенсировано увеличением вязкости и повышением темп-ры раствора. Существующие теории описывают эту деполаризацию как следствие изотропного (для сферич. частиц) или анизотропного (для эллиптич. частиц) вращений. Зависимость поляризации от разл. факторов в рамках этих теорий позволяют извлекать информацию о свойствах молекул (время жизни возбуждённого состояния τ , размеры и конфигурация молекул), а также получить характеристики окружающей среды (микро- и макровязкость, сольватные оболочки и др.). Эти методы находят применение в исследовании жидкого состояния, суспензий, мицеллярных раство-

ров, биол. объектов. На поляризацию люминесценции влияют также процессы тушения, сокращающие т. Концентрац. деполаризация вызывается процессами переноса энергии электронного возбуждения от первично возбужденных ориентиров. молекул к хаотически ориентированным нево возбужденным молекулам. Процессы переноса энергии возможны только при малых расстояниях между молекулами, т. е. при высоких концентрациях растворов. Зависимость поляризации люминесценции от концентрации растворов позволяет судить о механизмах переноса энергии возбуждения в разл. системах, в т. ч. биологических. Полная теория концентрации деполаризации должна учитывать мн. факторы (неоднородное уширение, обратный перенос энергии, переориентацию, процессы тушения и т. д.) и в наст. время (1990-е гг.) не завершена.

Использование для возбуждения мощного получения лазеров (и нек-рых др. источников мощного излучения) и развитие нелинейной оптики привело к обнаружению нелинейных явлений в П. л. Наведенная в изотропном растворе с помощью поляризов. света анизотропия по мере увеличения интенсивности возбуждения достигает насыщения сначала для наиб. вероятной для поглощения ориентации молекул, а затем для всех остальных ориентаций, в результате чего должна начаться деполаризация люминесценции. Процессы деполаризации при насыщении достаточно хорошо изучены и экспериментально, и теоретически. Наиб. ярко они проявляются у соединений с долгоживущими триплетными возбужденными состояниями.

Мощное световое возбуждение позволяет также осуществлять двухфотонное возбуждение молекул в растворе, причём наведенная поляризация люминесценции в этом случае может быть значительно выше, чем при одnofотонном возбуждении при сопоставимых условиях (напр., если для одnofотонного линейно поляризованного возбуждения изотропного раствора $\rho = 1/2$, то в сопоставимом случае двухфотонного возбуждения $\rho = 1/2$). Причина такого различия состоит в том, что второе анизотропное возбуждение происходит в среде, уже предварительно частично поляризованной первым анизотропным возбуждением.

Спектральные исследования П. л. растворов включают изучение зависимости ρ от длины волн возбуждения λ_b и люминесценции λ_l . Зависимость ρ от λ_b (поляризац. спектры) позволяет определить относит. ориентацию осциллятора излучения и осцилляторов, соответствующих разным полосам поглощения. Изменения ρ в зависимости от λ_l обычно невелики, определяются электронно-колебат. переходами и позволяют определять их симметрию. Применяя методы тонкоструктурной селективной спектроскопии (методы, основанные на Шпольского эффекте, или селективное лазерное возбуждение при низких темп-рах), удаётся измерить поляризацию отд. компонент в квазилинейчатых спектрах люминесценции, получать детальную интерпретацию колебат. структуры спектров и устанавливать симметрию колебаний. Подобные исследования проведены, напр., для такого важного класса органич. молекул, как порфирины, к к-рым относится хлорофилл и гемоглобин крови.

Угл. в пространств. характеристики поляризации люминесценции растворов, называемые поляризац. диаграммами, устанавливают зависимость степени поляризации от ориентации электрич. вектора возбуждающего света и направления наблюдения люминесценции. Исследование этих зависимостей позволяет определить природу элементарных излучателей.

В большинстве случаев люминесценция сложных молекул поляризована линейно (как правило, частично линейно). Однако для гиротропных веществ (см. Гиротропия), способных вращать плоскость поляризации и обладающих циркулярным дихроизмом, обнаруживается и частично циркулярная поляризация люминесценции. Особенно часто это наблюдается для биол.

объектов — белков, нуклеиновых кислот и их комплексов. Циркулярная поляризация даёт информацию о гиротропных свойствах молекул в возбуждённом состоянии, в то время как циркулярный дихроизм — о свойствах осн. состояния молекул.

П. л. кристаллов кубической симметрии также возникает при поляризов. возбуждении. Эти кристаллы представляют собой макроскопически изотропные среды со скрытой анизотропией локальных центров люминесценции, осцилляторы к-рых ориентированы по осям симметрии кристалла. Исследуя зависимость степени поляризации люминесценции центров окраски в кристаллах флюорита и др. кристаллах щёлочно-галогенных солей от ориентации электрич. вектора возбуждающего света относительно осей кристалла, на основе осцилляторных моделей можно определить, по каким осям кристалла ориентированы те или иные люминесцирующие центры окраски, и получить данные о характере и расположении атомов примесей в кристаллич. структуре.

В макроскопически изотропных кристаллах с анизотропными центрами люминесценции, как и для изотропных растворов, применим метод поляризац. диаграмм: изучение угл. и пространств. распределения поляризации люминесценции позволяет определить мультипольность излучателей.

Расмотренные методы не учитывают колебаний кристаллич. решётки и пригодны только для систем со слабым электрон-фононным взаимодействием. Для исследования систем с сильным электрон-фононным взаимодействием (напр., щёлочно-галогенных кристаллов, активизированных ионами Ga^{3+} , Ge^{2+} , In^{3+} , Sn^{2+} , Tl^{+} , Pb^{2+}) разработана теория, рассматривающая на основе эффектов Яна — Теллера (см. Вибронное взаимодействие) взаимодействие оптич. электронов примеси с неполюсимметричными колебаниями решётки. Исследование П. л. позволяет на основе этой теории устанавливать симметрию и структуру релаксированных возбуждённых состояний и характер протекающих в них процессов.

П. л. в среде с частичной ориентацией молекул. Такие среды можно представить как состоящие из двух частей — полностью ориентированной и хаотической. Первая испускает П. л. даже при изотропном возбуждении (спонтанная поляризация), для второй возможна П. л. лишь при анизотропном возбуждении. Исследование поляризации люминесценции таких сред позволяет судить о степени упорядоченности среды, характере ориентации излучающих частиц и её динамике.

Примерами сред с частичной ориентацией частиц являются полимерные и др. плёнки и волокна макромолекул, жидкие кристаллы и разл. биол. объекты. Для исследования таких сред используют также люминесценцию спец. «люминесцентных меток» — небольших молекул или групп атомов, присоединяемых к макромолекулам. Исследование вращат. деполаризации люминесценции позволяет изучать внутримолекулярную подвижность и движения макромолекул как целого, т. е. внутри- и межмолекулярные взаимодействия, конформации белковых молекул, вязкость внутрискелетной плазмы, механизмы функционирования биологически активных веществ, механизмы действия сократительного аппарата мышечных волокон, структуру биол. мембран и т. д.

П. л. молекулярных кристаллов. Молекулярные кристаллы представляют собой среды, в к-рых молекулы ориентированы полностью, но типов ориентации несколько (в оргвнич. кристаллах чаще 2 типа). Их люминесценция поляризована даже при изотропном возбуждении, но степень поляризации всегда меньше единицы. При поляризов. возбуждении степень поляризации люминесценции не зависит от ориентации вектора наприжения электрич. поля возбуждающего света, что объясняется *мириющей энергией* возбуждения от первично возбуждённых молекул к невозбужден-

ным молекулам др. ориентации. Т. о., с помощью исследования П. л. молекулярных кристаллов можно изучать миграцию эвергин в них. Пространств. и угл. распределение поляризации люминесценции таких кристаллов позволяет определить ориентацию молекулы в кристаллич. структуре. Особенно чувствителен этот метод при исследовании малых концентраций примесей. Поляризация люминесценции позволяет также различать молекулярное и эситонное излучения. Исследование П. л. двусвязных молекулярных кристаллов требует учета явления дупреломления как возбуждающего света, так и света люминесценции, а также др. кристаллооптич. факторов (дихроизм, вращение плоскости поляризации). Последнее необходимо и при изучении П. л. центров люминесценции в одноосных кристаллофорах типа ZnS. Исследование зависимости степени поляризации люминесценции от ориентации электрич. вектора возбуждающего света относительно осей кристалла, а также «спонтанной» поляризации при возбуждении неполяризов. светом и сравнение результатов с расчетами моделей линейного осциллятора и ротора после учета поправок на дупреломление позволили выяснить ряд важных и тонких деталей строения центров люминесценции в ZnS.

П. л. полупроводников при её рекомбинац. характере в зависимости от вида возбуждения может иметь как линейную, так и циркулярную поляризацию. При поглощении циркулярно поляризованного возбуждающего излучения электроны, переходя из валентной зоны в зону проводимости, ориентируются по спину. При рекомбинации электронов и дырок возникает циркулярно поляризованное излучение. Т. о., исследование поляризации рекомбинац. люминесценции позволяет определить степень ориентации неравновесных электронов. Т. к. измеремая экспериментально поляризация отражает ситуацию, к-рая складывается за время жизни неравновесного электрона вследствие разл. процессов спиновой релаксации и спиновых взаимодействий, этот метод применяют для изучения подобных процессов. С его помощью зарегистрировано сверхтонкое взаимодействие ориентиров. электронов и ядер кристаллич. структуры, раскрыта возможность накопления зарядч. ядерной поляризации и оптич. охлаждения системы ядерных спинов.

При межзонном поглощении линейно поляризованного света в полупроводниках электроны проводимости оказываются выстроенными по импульсам (скоростям) с преимуществ. направлением импульсов перпендикулярно вектору поляризации возбуждающего света. При рекомбинации таких анизотропно выстроенных электронов с дырками возникающая люминесценция частично линейно поляризована. Уменьшение степени поляризации в магн. поле позволяет следить за процессами энергетич. и импульсной релаксации электронов.

Лит.: Феофилов В. П., Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов, М., 1959; Буке Е. В., Григорьев Н. Н., Фокс М. В. Применение метода поляризационных диаграмм для исследования одноосных кристаллов, «Труды ФИАН», 1974, т. 79, с. 108; Блохин А. П., Толкачев В. А., Поляризация флуоресценции свободных многатоминых молекул, «Оптика и спектроскопия», 1981, т. 51, в. 2, с. 278; Зазубович С. Г., Исследование структуры возбужденных состояний ртутеподобных центров в кубических кристаллах методом поляризованной люминесценции, «Изв. АН СССР, Сер. физ. Матем. науки», 1986, № 2, с. 279; Захаров Н. Д., Б. П., Люминесценция полупроводников в условиях оптического охлаждения системы ядерных спинов, «Изв. АН СССР, Сер. физ.», 1982, т. 46, № 2, с. 394; Ануфриева Е. В., Поляризованная люминесценция и спектроскопия, 1981, с. 51; Люминесцентный анализ в медицине-биологических исследованиях, Рига, 1983, с. 25; Гайденко В. А., Сармеевич В. А. М., Анизотропия поглощения и люминесценции многотоминых молекул, Минск, 1986; Жвайдоров Н. Д., Оптическая анизотропия и миграция эвергина в молекулярных кристаллах, М., 1987; Зазубович С. Г., Нагайрин В. П., Соолян Т. А., Поляризованная люминесценция примесей в центрах кристаллов, «Изв. Д. ССР, Сер. физ.», 1988, т. 52, № 4, с. 674. Н. Д. Жвайдоров, ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ НЕЙТРОНЫ — совокупность нейтронов (лучок), спины к-рых и имеют преимуществ. ориентацию вдоль к.-л. выделенного направления в про-

странстве (оси квантования), обычно — направления магн. поля H . Нейтрон обладает спином $s = 1/2$ (в единицах постоянной Планка \hbar), поэтому возможны только 2 проекции спина на ось квантования вдоль и против неё. Пучок П. и характеризуется вектором поляризации P , к-рый равен удвоенному ср. значению (матем. ожиданию) проекции спина на H :

$$P = 2\langle s \rangle = \langle \sigma \rangle. \quad (1)$$

Здесь σ — Паули матрицы. Степень поляризации пучка нейтронов определяется выражением

$$P = (N_+ - N_-) / (N_+ + N_-), \quad (2)$$

где N_{\pm} — числа частиц в пучке с проекциями спина вдоль (+) и против (-) направления поля H . Если пучок не поляризован, то $N_+ = N_-$ и $P = 0$. Для полностью поляризованного пучка нейтронов $P = 1$. Полностью поляризованный пучок обладает чистым спиновым состоянием; спиновая часть волновой ф-ции такого состояния имеет вид

$$\Psi(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \cos \theta/2 \\ e^{i\varphi} \sin \theta/2 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Здесь θ, φ — полярные углы, характеризующие направление P . Проекция P в сферич. координатах:

$$P_x = P \sin \theta \cos \varphi; P_y = P \sin \theta \sin \varphi; P_z = P \cos \theta. \quad (4)$$

Реальные нейтронов. пучки не обладают полной поляризацией. Частично поляризованный пучок нейтронов ($0 < P < 1$) содержит некогерентную примесь др. спинового состояния. Неполяризов. пучок нейтронов ($P = 0$) можно рассматривать как состоящий из 2 полностью поляризованных пучков одинаковой интенсивности с противоположными знаками поляризации, во независимых друг от друга (некогерентных). Спиновое состояние частично поляризованного пучка (смешанное спиновое состояние) описывается не волновой ф-цией (3), а спиновой (поляризац.) матрицей плотности:

$$\rho = \frac{1}{2} (I + P\sigma). \quad (5)$$

Здесь I — единичная матрица. Выражение (5) принимают в качестве строгого определения понятия поляризации пучка нейтронов, эквивалентного (1).

Энергия взаимодействия нейтронов с магн. полем H :

$$U = -\mu_n H = -\gamma \mu_n \sigma H, \quad (6)$$

где μ_n — магн. момент нейтрона, μ_n — ядерный магнетон, $\gamma = -1,913$ — магн. момент нейтрона, выраженный в ядерных магнетонах. Можно показать, что движение спина нейтрона в поле H (в нерелятивистском случае) описывается ур-нием

$$\frac{dP}{dt} = \frac{2\mu_n}{\hbar} [PH]. \quad (7)$$

Ур-ние (7) допускает классич. трактовку: σ — единичный вектор, направленный вдоль вектора P . Согласно (7), вектор P прецессирует вокруг направления H с лариморовой частотой:

$$\omega_L = \frac{2\mu_n H}{\hbar} = \frac{2(\gamma \mu_n H)}{\hbar}. \quad (8)$$

Если напряжённость магн. поля H выражена в эрстедах, то $\omega_L = 1,8325 \cdot 10^4 H$ рад/с. Компоненты вектора P описываются выражениями

$$\begin{aligned} P_x(t) &= P_x(0) \cos \omega_L t - P_y(0) \sin \omega_L t, \\ P_y(t) &= P_x(0) \sin \omega_L t + P_y(0) \cos \omega_L t, \\ P_z(t) &= P_z(0). \end{aligned} \quad (9)$$

Решение ур-ния (7) показывает, что спин нейтрона адiabатически следует за направлением поля H , если

ного нейтронновода тем, что на отражающую нейтроны стеклянную поверхность 3 методом расплавления нанесён слой Co—Fe (сплав). Он легко намагничивается до насыщения и обеспечивает равенство величин магнитной и ядерной амплитуд рассеяния $b_M = b_d$. При этом полное внутр. отражение возможно только для одного спинового компонента. Чтобы уменьшить влияние отражения нейтронов пр. спинового состояния от стеклянной основы, на неё нанесён поглощающий подслои. Степень поляризации P достигает 97%.

Секция многоканального (многоканального) поляризующего нейтронвода (рис. 2) содержит пакет тонких стеклянных пластин 3, покрытых с обеих сторон слоями

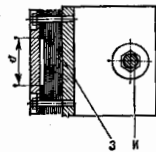


Рис. 2. Сечение многоканального поляризующего нейтронвода: 3 — пакет тонких зеркал, прикрывающий прокладками и базовой пластин; 4 — виток, изгибающий пластину.

смеси Co (60%) и Fe (40%) и разделённых прокладками. Ширина пучка нейтронов $a = 3$ см. Изгибая нейтронвод (виток), можно регулировать граничную длину волны нейтронов, способных испытывать полное отражение от стенок.

Анализатор. Степень поляризации P измеряют, используя анализаторы поляризации. Обычно анализатор устроен аналогично поляризатору. Если поляризатор — намагнитченное ферромагн. зеркало со степенью поляризации отражённого пучка P_1 , то анализатор — также зеркало с поляризующими свойствами P_2 . Это степень поляризации пучка, отражённого от анализатора, если на него падает пучок, вышедший из поляризатора, но деполаризованный. В общем случае $P_1 \neq P_2$.

В пространстве между поляризатором и анализатором помещают т. н. флиппер-устройство, в к-ром создаются условия для неадиабатич. спинового перехода ($\omega \gg \omega_L$), при к-ром направление поляризации пучка P реверсируется относительно направления ведущего поля. Таким устройством может служить плоская фольга (Al), через к-рую пропускают ток. Направление магн. поля, создаваемого током, изменяет ориентацию спина на малом расстоянии (на толщине фольги $\ll 0,1$ мм). Если флиппер выключен, в пространстве между поляризатором и анализатором выполняется условие $\omega \ll \omega_L$ (адиабатичность). Если включается флиппер, то ведущие поля до флиппера и после него имеют противоположные направления. Неадиабатич. переход осуществляется только в самом флиппере. Пусть f — вероятность изменения ориентации спина нейтрона на противоположную относительно направления ведущего поля. В адиабатич. областях $f = 0$. В неадиабатич. области $f \neq 0$. Полному реверсированию соответствует $f = 1$. За анализатором устанавливается нейтронный детектор, чувствительность к-рого от состояния поляризации не зависит (рис. 3). Если I — скорость счёта детектора, когда флиппер выключен, т.е. изменения ориентации спина нейтронов относительно ведущего поля не происходит ($f = 0$), а I' — скорость счёта

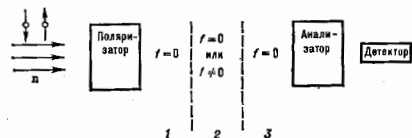


Рис. 3.

при включённом флиппере ($f = 1$), то имеет место соотношение

$$P_1 P_2 = \frac{R-1}{1-R(1-2f)} \approx \frac{R-1}{R+1} \quad (13)$$

Здесь $R = I/I'$ наз. поляризованным отношением.

Вместо флиппера можно использовать устройство, к-рое полностью деполаризует пучок нейтронов, в этом случае $f = 1/2$. В качестве деполаризатора обычно применяют немагнитичную железную фольгу (шим). Неупорядоченность направлений намагнитченности доменов в шиме и соответственно направлений спиновой ирреции приводит к полной деполаризации пучка нейтронов при толщине шима 0,1—0,3 мм. В этом случае выполняется соотношение

$$P_1 P_2 = R - 1. \quad (14)$$

Зная P_2 и пользуясь выражениями (13) или (14), можно найти P_1 .

Наиб. точный и при этом абс. метод измерения P основан на эффекте Штерпа — Герлаха. Пучок нейтронов пропускают через область с неоднородным магн. полем, в результате чего он расщепляется на 2 пучка, обладающих противоположными направлениями поляризации P (см. Штерпа — Герлаха *опт.*). Отношение интенсивностей этих пучков определяет степень поляризации падающего пучка нейтронов. Такое устройство применяют для создания полностью поляризованных пучков нейтронов, но светосила этого метода невелика, т. к. для полного разведения пучков в пространстве необходимо использовать узкие, сильно коллимированные пучки частиц.

Разработаны спец. анализаторы, позволяющие исследовать изменение как степени поляризации пучка нейтронов P , так и направления его поляризации P после прохождения через образец.

Применение. П. и используются в ядерной физике для изучения спиновой зависимости нейтронных сечений, измерения амплитуд когерентного и некогерентного рассеяния нейтронов (см. Нейтронграфия *структурная*), а также для исследования таких фундам. проблем, как несохранение пространственной чётности в ядерных реакциях, поиск нарушения временной инвариантности, определение угл. корреляций в бетараспаде свободных нейтронов, поиске электрич. заряда и электрич. дипольного момента нейтрона и т. д. В физике твёрдого тела П. и позволяют изучать магн. структуры, конфигурации неспаренных электронов (спиновую плотность) в магнетиках (см. Магнетизм *нейтроннография*), измерять магн. моменты отд. компонентов в сплавах, исследовать кинетику фазовых переходов, ядерных релакс. процессов, миграцию спинового возбуждения, в т. ч. в неупорядоченных спиновых системах, идентифицировать короткоживущие дефекты в кристаллах, исследовать спиновые волны в магнетиках и т. д.

Знак Ю. Г. Гузько А. Д. Кручинский П. А. Поляризованные медленные нейтроны, М. 1966. Кемпфер Ф. Основные положения квантовой механики, [пер. с англ.], М. 1967; Окороков А. И. и др. Определённые пространственной ориентации поляризации нейтронов и исследование намагнитченности вблизи точки фазового перехода «ЯЭТО», 1975, т. 69, в. 2, с. 590; Наутер Г. В. Polarized neutrons, in: Neutron diffraction, В.—[а.о.], 1978; Шелестов А. Б. Создание и исследование серии поляризованных нейтронов на базе зеркала СоFe с подслоем TiGa, М. 1978 (авторф. дис.); Кручинский В. П. А., Фундаментальные исследования с поляризованными медленными нейтронами, М. 1985. Ю. Г. Абс.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЯДРА — см. Ориентированные ядра.

ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ атомов, ионов и молекул — способность этих частиц приобретать электрич. дипольный момент p в электрич. поле E . В электрич. поле заряды, входящие в состав атома (молекулы, иона), смещаются один относительно другого — у частицы появляется индуциров. дипольный момент, к-рый

всечает при выключении поля. Понятие П., как правило, не относят к частицам, обладающим постоянным дипольным моментом (напр., к полярным молекулам). В отношении слабых электрич. полей

$$p = \alpha E; \quad (1)$$

коэф. α также наз. П., он является её количеств. мерой (имеет размерность объёма). Для атомных систем, напр. нек-рых молекул, П. может быть анизотропной. В этом случае зависимость $p(E)$ более сложная:

$$p_i = \sum_j \alpha_{ij} E_j,$$

где $\|\alpha_{ij}\|$ — симметричный тензор 2-го ранга, $i, j = x, y, z$. В сильных электрич. полях зависимость $p(E)$ перестаёт быть линейной.

Для изолированной i -й частицы (напр., молекулы разреженного газа) значение напряжённости поля E_i (поля в месте нахождения частицы) совпадает с напряжённостью внеш. поля $E_{\text{внеш}}$. Для частиц жидкости или кристалла к $E_{\text{внеш}}$ добавляется $E_{\text{внутр}}$ — поле, создаваемое зарядами др. частиц, окружающих данную (локальное поле).

При включении поля момент p появляется не мгновенно; время установления p для каждого типа частиц различно в зависимости от их физ. природы и характеризуется временем релаксации τ .

Наб. применение понятие П. получило в физике диэлектриков. Здесь оно определяет поляризацию среды P , диэлектрич. восприимчивость χ , диэлектрич. проницаемость ϵ . В простейшем случае

$$P = \sum_i p_i = \sum_i \alpha_i E_i;$$

$$\chi = \alpha N; \quad \epsilon = 1 + 4\pi \alpha N$$

(сумма берётся по всем N частицам в единице объёма). Понятие П. используется в физике молекул и физ. химии. Результаты измерений p, ϵ, χ, P и оптич. характеристик среды всегда содержат информацию о П. составляющих её частиц.

Случаю статич. поля E отвечает статич. значение П., являющееся одной из важных индивидуальных характеристик частиц. В перем. поле E (напр., в простейшем случае гармонич. зависимости E от времени) П. зависит от частоты ω колебаний поля и её удобно представить в виде комплексной величины: $\alpha(\omega) = \alpha_1(\omega) + i\alpha_2(\omega)$. Конкретный характер поведения П. в таком поле зависит прежде всего от времени релаксации τ . При достаточных низких частотах ω и коротких τ момент p устанавливается практически синфазно с изменением поля. При очень высоких ω или больших τ момент p может вообще не возникать; частица «не чувствует» присутствия поля, П. отсутствует. В промежуточных случаях (особенно при $\omega \sim 1/\tau$) наблюдаются явления дисперсии и поглощения и зависимость $\alpha(\omega)$ носит чётко выраженный и иногда весьма сложный характер.

Различают следующие виды П.

Электронная П. ($\alpha_{\text{эл}}$) обусловлена смещением в поле E электронных оболочек относительно атомных ядер. Величина α для атомов и ионов порядка их объёма ($\sim 10^{-24}$ см³), а $\tau \sim 10^{-14} - 10^{-16}$ с. Электронная П. имеет место во всех атомных и атомных системах, но в ряде случаев может маскироваться из-за малой величины другими, более сильными видами П.

Ионная П. ($\alpha_{\text{и}}$) в ионных кристаллах обусловлена упругим смещением в поле E равноионных ионов из их положений равновесия в противоположных друг относительно друга направлениях. В простейшем случае ионных кристаллов типа NaCl величина

$$\alpha_{\text{и}} = \frac{Z^2}{\omega^2 - \omega_0^2} \cdot \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}, \quad (2)$$

где m_1 и m_2 — массы ионов, Z_e — их заряд, ω_0 — собствен. частота упругих колебаний ионов кристалла (оптич. ветвь), ω — частота внеш. поля (для статич. поля $\omega = 0$). Время релаксации $\tau \sim 10^{-12} - 10^{-10}$ с (частота релаксации $\omega_{\text{рел}} = 1/\tau$ лежит в ИК-области спектра).

Атомная П. ($\alpha_{\text{ат}}$) молекул обусловлена смещением в поле E атомов разного типа в молекуле (что связано с несимметричным распределением в молекуле электронной плотности). Этот вид П. обычно составляет $\sim 1/10$ от $\alpha_{\text{эл}}$, $\tau \sim 10^{-12} - 10^{-10}$ с. Иногда атомной П. называют также П., связанную со смещением электронов, обеспечивающих ковалентные связи в кристаллах типа алмаза (Ge, Si). Температурная зависимость всех этих видов П., особенно $\alpha_{\text{эл}}$, слабая (с ростом T П. несколько уменьшается).

В физике диэлектриков все виды поляризации связывают с тем или иным видом П. Помимо перечисленных здесь вводятся и др. виды П., наиб. важные из них — ориентационная и релаксационная. Характерная особенность этих видов П. — реэкая зависимость от температуры, что позволяет выдвинуть их при эксперим. определениях.

Ориентационная П. ($\alpha_{\text{ор}}$) вводится для полярных диэлектриков (газов, жидкостей), состоящих из молекул с пост. дипольными моментами, а также и для кристаллов, в k -рых дипольные моменты могут поворачиваться. Если диэлектрик состоит из одинаковых молекул, имеющих пост. дипольный момент p_0 , то ориентация П. $\alpha_{\text{ор}}$ определяется как ср. значение поляризации $P = \sum p_0 E_i$, отнесённое к одной молекуле ($p_0 E_i$ — проекция момента p_0 i -й молекулы на направление поля E), т. е.

$$\alpha_{\text{ор}} = \sum_i p_0 E_i / N.$$

Ориентация p_0 в поле E нарушается тепловым движением, поэтому $\alpha_{\text{ор}}$ сильно зависит от температуры:

$$\alpha_{\text{ор}} = \frac{p_0^2}{3kT}.$$

Релаксационная П. (тепловая; $\alpha_{\text{рел}}$) вводится обычно для ионных кристаллов, где у слабо связанных ионов имеются два (или более) равновесных положения, k -рые в поле E становятся неравновесными, что приводит к появлению поляризации среды и, следовательно, к возможности ввести среднюю (па но) П. Расчёт (подтверждаемый опытом) даёт: $\alpha_{\text{рел}} = Z^2 b^2 / 12kT$, где b — расстояние между равновесными положениями ионов.

Для этих видов П. значения τ лежат в широком диапазоне ($\sim 10^{-2} - 10^{-12}$ с) и сильно зависят от температуры и др. внеш. условий. В случае переменных полей $\alpha_{\text{ор}}$ и $\alpha_{\text{рел}}$ зависит от частоты внеш. поля так же, как др. виды П. При рассмотрении поляризации гетерогенных диэлектриков понятие П. обычно не используется.

В литературе по физике диэлектриков П. иногда наз. коэф. пропорциональности χ между P и E ($P = \chi E$), т. е. диэлектрич. восприимчивостью.

Для относительно простых систем связь между электронной П. и макроскопич. характеристиками вещества описывается Лоренца — Лоренца формулой или Клаузиуса — Мосотти формулой, а с учётом $\alpha_{\text{ор}}$ — Ланджвена — Дебая формулой, и их усложнёнными модификациями. Эти зависимости — основа для эксперим. определения α . Ионную П. определяют по ф-лам типа (2). Сопоставление опытных и теоретич. данных для поглощения и дисперсии эл.-магн. волн, диэлектрич. потерь и т. д. даёт информацию как о П., так и о ходе её изменений с частотой внеш. поля. Свойства (и эффекты, в k -рых они проявляются) многих молекул и их систем (в частности, анизотропные) часто обусловлены их П. и П. составляющих их частиц. Примерами таких свойств и эффектов являются поляризация и рассеяние (в т. ч.

комбинационное) света, оптика, активность, эффект Керра и т. д. Изучение Π , в её теории тесно связано с исследованием межмолекулярных взаимодействий, структур молекул, особенно таких сложных, как полимеры, в частности белки.

В сильных электрич. полях зависимость $\rho(E)$ становится величайшей (см. *Нелинейные восприимчивости*).

ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ РЕНТГЕНОВСКАЯ — способность вещества поляризоваться под действием внеш. поля рентг. эл.-магн. волны; количественно равна коэф. пропорциональности χ между поляризацией P единицы объёма вещества и единичной напряжённости внеш. электрич. поля E . Свойства Π р. существенно отличаются от поляризуемости атомов, монов и молекул в поле оптич. диапазона, где при переходе к описанию диэлектрич. свойств вещества вводится понятие диэлектрич. восприимчивости. В рентг. диапазоне длина волны значения этих величин практически совпадают, поэтому обычно ограничиваются введением лишь понятия Π р.

Специфич. особенности Π р. обусловлены 4 причинами: длина волны λ излучения, радиус атома r_0 и параметр решётки кристалла a связаны соотношением $\lambda < r_0 \leq a$; частота излучения ω обычно того же порядка, что и частота атомного K - или L -уровня (для элементов с ат. номером $Z \geq 25$); все уровни энергии атома, лежащие выше K - и L -оболочек, заняты, и переходы на них невозможны; внутр. электронные оболочки атомов, с K -рыми наиб. сильно взаимодействуют рентг. излучение, целиком заполнены, сферически симметричны и имеют высокие значения энергий связи. Хим. связь или внеш. воздействия оказывают на внутр. электронные оболочки слабое влияние, поэтому можно считать, что они незначительно отличаются от таких же оболочек свободных атомов.

В рентг. диапазоне введение ср. Π р. теряет смысл. Обычно проводимое усреднение диэлектрич. свойств вещества в объёме с линейными размерами $l \ll \lambda$ невозможно по двум причинам: вследствие малой плотности содержащихся в таком объёме зарядов, а также характерного масштаба локальных изменений электронной плотности, k -ый порядка или больше λ . Поэтому поляризацию единицы объёма среды $P(r)$ вычисляют в каждой точке пространства с радиусом-вектором r , проводя лишь квантомеханич. усреднение по электронным состояниям. В этом случае в лицевом по полю приближения связь между векторами поляризации среды и напряжённостью поля имеет вид

$$P(r) = \hat{\chi}(r)E(r), \quad (1)$$

где Π р. $\hat{\chi}(r)$ — тензорная величина и является ф-цией координат:

$$\hat{\chi}(r) = -r_0 \lambda^2 \hat{\rho}(r),$$

где $r_0 = e^2/(mc^2)$ — классич. радиус электрона, $\hat{\rho}(r)$ — электронная плотность, $\lambda = \lambda_0/(2\pi)$.

Наиб. ярко особенности Π р. проявляются для кристаллов, где материальный тензор $\hat{\chi}(r)$ из-за трёхмерной периодичности кристаллич. решётки также является трёхмерно-периодической ф-цией координат: $\hat{\chi}(k + R) = \hat{\chi}(k)$, где R — любой вектор трансляции кристаллич. решётки. При рассмотрении отклика среды на возмущение в виде плоской монохроматич. волны необходимо в (1) перейти к фурье-компонентам. Ввиду пространств. периодичности тензора Π р. $\hat{\chi}(r)$ фурье-образ (1) имеет вид

$$P_i(k, \omega) = \sum_H \chi_{ij}^H(k, \omega) E_j(k + H, \omega), \quad (2)$$

где H — векторы *обратной решётки* кристалла. Сумма в правой части ф-лы (2) означает, что в плоскую волну поляризации среды с амплитудой $P_i(k, \omega)$ и волновым вектором k дают вклад все поля $E_j(k + H, \omega)$, k -ые распространяются в направлениях $k' = k + H$, от-

личаясь от k на произвольный вектор H (см. *Бразьян — Вульфур условие*), т. е. имеет место неколлажное взаимодействие полей в пространстве волновых векторов. Диэлектрич. свойства кристалла, следовательно, характеризуются набором Π р. $\chi_{ij}^H(k, \omega)$, отвечающих возможным направлениям распространения дифракц. волн в кристалле. В ф-ле (2) формально присутствует суммирование по всей бесконечной совокупности векторов обратной решётки H . Реально в кристалле могут распространяться одновременно лишь неск. полей $E(k, \omega)$, для k -рых удовлетворяются условия дифракции. Отскакивание волновых векторов k' и амплитуду $E(k', \omega)$ является задачей теории дифракции рентгеновских лучей.

В первом приближении теории возмущений Π р. χ_{ij}^H многоатомного кристалла пропорциональна тензору структурного фактора $F_{ij}(k, k'; \omega)$:

$$\chi_{ij}^H = -\frac{N e^2}{V m^2} F_{ij}(k, k'; \omega) \delta_{k' - k, H}, \quad (3)$$

где Кронекера символ $\delta_{k' - k, H}$ указывает на отличие Π р. от нуля только в дифракц. направлениях $k' = k + H$; m — масса атома. Согласно (3), Π р. отрицательна и по абс. величине составляет $\sim 10^{-6}$. Для одноатомных кристаллов тензор структурного фактора в (3) заменяется на тензор атомного фактора $f_{ij}(k, k'; \omega)$, в k -ый аддитивно входят разл. вклады: потенциальный $f(k - k')$, очень слабо зависящий от частоты ω и дающий осн. вклад в Π р.; резонансный $\Delta f_{ij}(k, k'; \omega) = \Delta f_{ij}^+(k, k'; \omega) + \Delta f_{ij}^-(k, k'; \omega)$, заметный только на частотах, близких к характеристическим; неупругий $\Delta f_{ij}^{un}(k, k'; \omega)$, k -рый в свою очередь складывается из теплодиффузного, комптоновского и рамановского (последний вклад имеет дисперсионную зависимость от частоты и не превышает неск. процентов).

Зависимость тензора Π р. от векторов k и H — следствие пространственной дисперсии, параметр k -рой $a/\lambda \sim r_0/\lambda \geq 1$ чрезвычайно велик (в оптич. диапазоне $a/\lambda \leq 10^{-3}$). Пространственная дисперсия вызывается двумя причинами: трёхмерно-периодич. расположением атомов в решётке, что ведёт к резкому пространственному перераспределению рассеянной интенсивности — дифракции; на неё накладываются монотонная и планная зависимости Π р. от угла рассеяния, обусловленные внутр. строением атомов и тепловыми колебаниями атомов кристалла. Количественно влияние темп-ры на Π р. учитывается введением Дебая — Уоллера фактора.

Т. к. внутр. электронные оболочки, наиб. сильно взаимодействующие с рентг. излучением, целиком заполнены, сферически симметричны и их электроны имеют высокие значения энергии связи, в рентг. диапазоне заметных эффектов *оптической активности* и *анизотропии* нет, поэтому электронную часть Π р. обычно можно считать скалярной. Однако деформация электронных оболочек, вызванные хим. связью и анизотропией тепловых колебаний атомов, благодаря дифракции можно наблюдать. Деформация внутр. сферич. электронных оболочек ведёт к понижению симметрии кристалла и, как следствие, к появлению в дифракц. картине новых («запрещённых») дифракц. отражений с малой интенсивностью, появляющихся под иными, нежели разрешёнными, углами.

Т. к., согласно (3), $\chi_{ij}^H(k, \omega) \sim 1/m$, ядра из-за большой массы нуклонов дают по сравнению с электронами пренебрежимо малый вклад в Π р. Однако если кристалл содержит изотопы с низколежущими ядерными резонансами (см. *Мессбауэра эффект*), то соответствующее резонансное рентг. излучение взаимодействует не только с электронами, но и с ядрами. Резонансное взаимодействие такого излучения с ядрами весьма интенсивно, так что вклад ядерной подсистемы в Π р. может на порядок превышать вклад от электронов и

достигать величины $\sim 10^{-5}$. Низколежащие ядерные γ -переходы обычно алектрические квадрупольные или магнитные дипольные, поэтому даже в отсутствие сверхтокового рассеяния ядерных уровней энергии среда обладает поделит. пространств. дисперсией. При резонансном рассеянии излучения на ядрах внедрё в среду является изотропной и негетропной. Для мягягитого дипольного перехода это же справедливо и в любом дйфракт. направлении. В случае алектрического квадрупольного перехода вектор обратной решётки H характеризуется в пространстве векр-м. направлением, поэтому возникает оптич. анизотропный свойст. кристалла. Магн. и (или) оптич. сверхтонкое взаимодействие, к-рое приводит к снвтию вырождения ядерных уровней, вносит дополнит. анизотропию. В присутствии сверхтокового рассеяния среда и в прямом направлении приобретает оптич. активность. На частотах ядерных γ -переходов можно наблюдать хорошо выраженные эффекты частотной и пространств. дисперсии, а также естественной (т. е. вызванной внутр. сверхтонкими взаимодействиями) и наведённой внеш. полями оптич. активности и анизотропии. Для учёта аддитивного резонансного вклада в П. р. в (3) следует дополнительно добавить тензор ядерного структурного фактора. Температурное поведение ядерного вклада в П. р. определяется ф-актором Ламба Λ — Мёссбауэра.

Для П. р. характерен ряд особых симметричных соотношений, в к-рых наряду с теоретическими индексами (i, j) и волновым вектором k участвует также и вектор обратной решётки H . Напр., применение флуотационно-дисперсионной теоремы с учётом (3) для непоглощающего кристалла приводит к следующему симметричному соотношению:

$$\chi_{ij}^{H^+}(\omega) = \chi_{ij}^H(-k-H; -\omega) = \chi_{ij}^{-H^*}(k+H; \omega),$$

ва к-рого следует эквивалентность отражений с вектором дифракции H и $-H$ (закон Фриделя). Следовательно, с помощью дифракции нельзя различить centrosymmetric и noncentrosymmetric кристаллов.

П. р. обычным образом связана с диалектрической проницаемостью ϵ :

$$\epsilon_{ij}^{H^+} = \delta_{ij} \delta_{nn} + 4\pi \chi_{ij}^{H^+}(k, \omega).$$

Для направления рассеяния вперёд ($k' = k, H = 0$) можно ввести показатель преломления $n(k, \omega)$:

$$n(k, \omega) = \left(\epsilon_{ij}^0 + \epsilon_{ij}^0(k, \omega) \epsilon_j \right)^{1/2} \approx 1 - 2\pi \frac{N}{V} \frac{e^2}{m\omega^2} F(k, 0, \omega),$$

где $F(k, 0; \omega)$ — структурный фактор рассеяния на нулевой угле, $F(k, 0; \omega) = (\epsilon_{ij}^0 F_{ij}(k, \omega) \delta_{k-k'}; 0 \epsilon_j)$; ϵ_j и ϵ_j^0 — единичные векторы поляризации падающего л рассеянного излучений. Показатель преломления $n(k, \omega)$ меньше единицы на $\sim 10^{-5}$. Это означает, что эффект преломления и рефл. диапозоне очень слабый, а среда имеет меньшую оптич. плотность, чем вакуум. В соответствии с этим в рефл. оптике говорят о полном внешнем отражении и критич. угол к-рого выражается через нулевую фурье-компоненту П. р.:

$$\theta_n \approx 2\sqrt{\pi \chi^0(k, \omega)} \sim 10^{-3} \text{ рад.}$$

Мнимая часть П. р. определяет линейный коэф. поглощения излучения в среде:

$$\mu(k, \omega) = -\frac{\omega}{c} \text{Im} \chi^0(k, \omega) = \frac{\omega}{c} \frac{N}{V} \frac{e^2}{m\omega^2} \text{Im} F(0, \omega).$$

Эффекты локального поля в рефл. диапозоне чрезвычайно малы и никогда не учитываются.

Несовершенство строения реального кристалла (точечные дефекты, дислокации, деформации и т. д.), если их присутствие не ведёт к изменению рассеивающей

способности атомов, можно описать, введя ф-цию смещения узла кристаллич. решётки $u(r, t)$. Тогда с координатном пространстве П. р. уже не является периодич. ф-цией и приближённо её можно задать выражением $\chi(r+u, t, \omega)$. При достаточном малых смещениях кристалл по-прежнему характеризуется набором П. р. для каждого дйфракт. направления, однако в этом случае фурье-компоненты П. р. являются ещё и ф-циями координат: $\chi^H(r, k; \omega)$. Зависимость П. р. от координат ведёт к размыванию дйформации дйфракт. максимумов. Напр., если $u(r)$ имеет гармонич. зависимость от координат, то П. р. отличается от нуля не только в направлениях $k' = k + H$, но и в близких к ним направлениях $k' = k + H + lq$ (т. е. спутниках), где q — волновой вектор ф-ции смещения $u(r, t)$, а $l = \pm 1, \pm 2, \dots$ — порядков спутника; спутники одного номера, но с противоположными знаками располагаются симметрично относительно осев. максимумов.

П. р. для аморфных веществ и жидкостей, где существует лишь ближний порядок в расположении атомов, не имеет таких ярких ф-н. проявлений, как в кристаллах. П. р., как и поляризуемость в др. диапозонах электромагн. спектра, является универсальной характеристикой диалектрич. свойств среды. С её помощью возможно описание всех оптич. явлений в рефл. диапозоне, и прежде всего дйфракции.

Лит.: Дж. В. ван Р., Оптические принципы дйфракции рентгеновских лучей, пер. с англ., М., 1950; Колпаков А. В., Бушуй В. А., Кузьмин Р. Н., Диалектрическая проницаемость в рефл. диапозоне частот, *ЖФН*, 1978, т. 126, в. 3, с. 478. А. В. Колпаков.

ПОЛЯРИМЕТР — 1) прибор для измерения угла вращения плоскости поляризации монохроматич. света в шестицах, обладающих естественной или наведённой оптич. активностью. Дисперсию оптического вращения измеряют спектрополяриметрами.

П. делается на иауальные и фотоэлектр. приёмы. Конечным измерит. элементом и тех, и других является светочувствит. устройство (глаз или фотоэлектрич. приёмник), реагирующее на изменение интенсивности света, а не на состояние его поляризации. Этот принцип реализуется, напр., в П., построенных по схеме *полупетлевых приборов*. Исследуемое вещество 5 (рис. 1) помещается между полупетлевыми поляризатором, состоящим из двух половинок 3—4, и анализатором б.

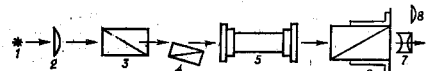
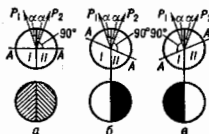


Рис. 1. Принципиальная схема полупетлевого поляриметра: 1 — источник света; 2 — конденсор; 3—4 — полупетлевый поляризатор; 5 — трубка с исследуемым оптически активным веществом; 6 — анализатор с оптичным устройством; 7 — аналитическая трубка; 8 — окуляр счётного устройства.

Пропускание анализатора меняется в соответствии с *Малюса законом* при изменении угла ϕ между плоскостью поляризации AA анализатора и плоскостью поляризации падающего на него света. Наиб. абс. изменение интенсивности прошедшего через анализатор света в зависимости от угла ϕ происходит вблизи угла $\sim 45^\circ$; однако относит. изменение интенсивности максимално вблизи угла $\sim 90^\circ$. Действительно, $(\Delta I/I)/\Delta \phi \approx 2 \tan \phi \rightarrow \infty$ при $\phi \rightarrow 90^\circ$. Поэтому для наиб. чувствительной регистрации малых углов вращения плоскости поляризации анализатора AA устанавливается перпендикулярно бисектрисе малого угла 2а между плоскостями поляризации P_1 и P_2 двух половинок полупетлевого поляризатора (рис. 2, а). В таком случае обе половины I и II поля зрения имеют одинаковую освещённость. Когда между поляризатором и анализатором находится исследуемое вещество, поворачивающее плоскость поляризации, освещённость резко меняется (рис. 2, б,

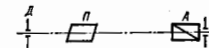
Рис. 2. Полученные поляризаторы: А — плоскость поляризации анализатора; Р, и Р₁ — плоскости поляризации двух половин поляризатора; 2α — угол между ними.



а). Измерение угла вращения сводится к повороту плоскости поляризации анализатора до визуального выравнивания яркостей двух половин поля зрения. Измеряемый угол считывается со шкалы отсчетного устройства. Подобная методика визуальной регистрации обладает достаточно высокой чувствительностью, что позволяет применять полученные П. при разл. исследованиях. Однако более распространены автоматич. фотоэлектр. П., в к-рых совмещение двух интенсивностей осуществляется с помощью поляризац. модуляции светового потока (см. Модуляция света). Последний в свою очередь вызывает переменный фототок, к-рый после усиления и выпрямления регистрируется, а с помощью компенсирующей схемы производится измерение угла. Макс. пороговая чувствительность лазерных П. $\sim 10^{-7}$ град; при использовании внутрирезонаторных лазерных методов измерений чувствительность П. доходит до $5 \cdot 10^{-8}$ град.

2) П. — также прибор для определения степени и поляризации в р частично поляризованного света. Степень линейной поляризации устанавливается как отношение разности в сумме интенсивностей I_1 и I_2 света, разложенного на две линейно поляризованные составляющие с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации, т. е. $p = (I_1 - I_2)/(I_1 + I_2)$. Простейший визуальный полученный поляриметр Корню (рис. 3) состоит из диафрагмы Д, призмы Волластона П и анализатора А. Призма Волластона пространственно разделяет составляющие I_1 и I_2 , в результате чего

Рис. 3. Схема поляриметра Корню: Д — диафрагма; П — призма Волластона; А — анализатор.



через анализатор наблюдаются два поля изображения диафрагмы, интенсивности к-рых в соответствии с законом Малюса равны $I_1 = I_0 \cos^2 \psi$ и $I_2 = I_0 \sin^2 \psi$. Поворачивая анализатор на угол ψ , добиваются равенства интенсивностей обоих полей $I_1 = I_2$. Зная угол поворота ψ , определяют отношение $I_1/I_2 = \tan^2 \psi = \beta$ и степень поляризации $p = (\beta - 1)/(\beta + 1)$. Обычно шкала поворота градуирована непосредственно в значениях р.

В качестве П. используют и полярископ Савара, перед к-рым устанавливают поляризац. столу стеклянных пластин для компенсации измеряемой поляризации света. Поворачивая предварительно градуированную столу, добиваются того, чтобы анализируемый свет на выходе имел нулевую поляризацию.

Фотоэлектр. П. для измерения степени поляризации состоит из вращающейся полуволновой фазовой пластинки или пластинки в четверть длины волны (для определения степени линейной или циркулярной поляризации соответственно), анализатора и фотоприёмника. Отношение амплитуд переменной и постоянной составляющих фототока непосредственно даёт величину Р.

П. широко и эффективно применяются в разл. исследованиях структуры и свойств вещества, в решении ряда техн. задач. В частности, измерения степени поляризации излучения космич. объектов позволяют обнаружить сильные магн. поля во Вселенной.

Лит.: Шилдский А. А., Прикладная физическая оптика, М., 1961; Занасский В. С., Методы высокочувствительных поляриметрических измерений. (Обзор). Журнал прикладной спектроскопии, 1982, т. 37, в. 2, с. 184. Журнал прикладной спектроскопии, 1982, т. 37, в. 2, с. 184.

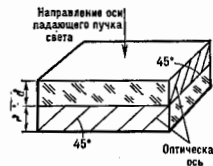
В. С. Занасский.

ПОЛЯРИМЕТРИЯ — оптич. методы исследования сред с естественной или наведенной магн. полем оптической активностью, основанные на измерениях величины вращения плоскости поляризации света с помощью поляриметров и спектрополяриметров. Поляриметр, и спектрополяриметр, исследования сред с естеств. оптич. активностью используются для измерения концентрации оптически активных молекул в растворах (см. Сахариметрия), для изучения структуры молекул и кристаллов, межмолекулярных взаимодействий, идентификация электронных переходов в спектрах поглощения оптически активных систем, определение симметрии ближайшего окружения молекул в жидкости или в твёрдом теле и т. д.

П. намагнитических сред по существу представляет собой один из разделов магнитооптики, охватывающийся на исследования Фараде эффекта. П. и спектрополяриметрия намагнитических сред позволяют исследовать энергетич. структуру электронных состояний и магн. свойства вещества.

К П. также часто относят методы определения характера поляризации оптич. излучения и измерения степени его поляризации.

ПОЛЯРИСКОП — оптич. прибор для определения поляризации света, основанный на явлениях интерференции поляризованных лучей. Типичный П. — полярископ Савара (рис.), состоящий из двух склеенных пластинок кристалла кварца одинаковой толщины d, вырезанных



так, что их оптич. оси составляют с осью П. углы в 45° , и анализатора, плоскость поляризации к-рого направлена под 45° к гл. сечениям верхней пластинки. При падении частично поляризованного света в поле зрения наблюдаются интерференц. полосы. В случае полностью неполяризованного света полосы отсутствуют при любой ориентации П.

В. С. Занасский, ПОЛЯРИТОН — составная квазичастица, возникающая при взаимодействии фотонов и элементарных возбуждений среды. Взаимодействие ал-магн. волн с возбуждениями среды, приводящее к их связи, становится особенно сильным, когда их частоты ω и волновые векторы k совпадают (резонанс). В этой области образуются связанные волны, т. е. П., к-рые обладают характерным законом дисперсии $\omega(k)$. Их энергия состоит частично из ал-магнитной и частично из энергии собств. возбуждений среды П., образующихся в результате взаимодействия фотонов с разл. возбуждениями среды — оптич. фононами, экситонами, плазмонами, магнонами и т. д., наз. соответственно фононами П., экситонами П. (светоэкситонами), и плазмонами П., магнонами П. и т. д.

Для описания фононных П. необходимо решить уравн. колебаний кристаллич. решётки совместно с уравн. Максвелла. В простейшем случае кубич. кристалла с изолятор. фононным резонансом на частоте ω_0 решение даёт след. соотношение для дисперсии фононных П. (без учёта затухания):

$$\left(\frac{kc}{\omega}\right)^2 = \varepsilon(\omega) = \frac{\omega^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \varepsilon_\infty. \quad (1)$$

Здесь ε — диэлектрическая проницаемость среды, ε_∞ — высокочастотная (по отношению к ω_0) диэлектрич.

проницаемость, ω_0 , ω_L — частоты поперечного и продольного длинноволновых оптических фононов (см. Колебания кристаллической решетки, Фонон). Дисперсия П. показана на рис. 1 сплошными кривыми 1 и 2; штриховыми линиями показаны дисперсия не взаимодействующих фотонов $k^2c^2/\omega^2 = \epsilon_\infty$ (3) и поперечных фононов (4) при малых значениях волнового вектора k ; тонкая линия 5 соответствует дисперсии фотонов в вакууме $k^2c^2/\omega^2 = 1$. Взаимодействие приводит к образованию двух дисперсионных ветвей 1 и 2 (нижней и верхней), разделенных щелью, простирающейся от частоты поперечного оптического фонона ω_0 (перевалас) до частоты продольного оптического фонона ω_L , определяемой из длинноволновых П. нижней ветви $(kc/\omega)^2 = \epsilon_0$, где ϵ_0 — статическая диэлектрическая проницаемость. На рис. 2 показана зависимость от k доли р фоновой энергии в П. нижней (1) и верхней (2) ветвях. Лишь в области с очень большими величинами волновых векторов k , где $\rho = 0$ или 1, П. имеют фотонный или фононный характер, а во всей промежуточной области — смешанный. Т. о., П. представляют собой

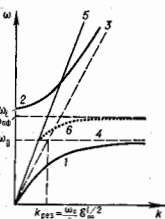


рис. 1. Дисперсия фононных поляритонов.

состояния (нормальные волны) полной системы — среда плюс эл.-магн. поле, а фотоны и фононы становятся нормальными волнами лишь вдали от области резонансного пересечения дисперсионных ветвей не взаимодействующих фотонов и фононов.

Звертываясь щель между ω_0 и ω_L отвечает отрицательному значению диэлектрической проницаемости среды. На таких частотах эл.-магн. волна не может распространяться в среде (волновой вектор в этой области частот является, как следует из (1), чисто мнимой величиной). Однако в этой области частот могут существовать т. н. поверхностные П. (поверхностные эл.-магн. волны), к-рые распространяются вдоль границы раздела двух сред. Их амплитуда экспоненциально падает при удалении от границы раздела. Поверхностные П. являются нерадиационными волнами, т. к. они не могут ни превращаться в фотоны, уходящие от поверхности, ни возбуждаться при простом освещении поверхности. В случае плоской границы среды с вакуумом дисперсия поверхностных П. определяется соотношением

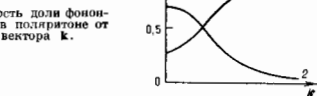


рис. 2. Зависимость доли фоновой энергии ρ в поляритоне от волнового вектора k.

собств. состояния (нормальные волны) полной системы — среда плюс эл.-магн. поле, а фотоны и фононы становятся нормальными волнами лишь вдали от области резонансного пересечения дисперсионных ветвей не взаимодействующих фотонов и фононов.

Звертываясь щель между ω_0 и ω_L отвечает отрицательному значению диэлектрической проницаемости среды. На таких частотах эл.-магн. волна не может распространяться в среде (волновой вектор в этой области частот является, как следует из (1), чисто мнимой величиной). Однако в этой области частот могут существовать т. н. поверхностные П. (поверхностные эл.-магн. волны), к-рые распространяются вдоль границы раздела двух сред. Их амплитуда экспоненциально падает при удалении от границы раздела. Поверхностные П. являются нерадиационными волнами, т. к. они не могут ни превращаться в фотоны, уходящие от поверхности, ни возбуждаться при простом освещении поверхности. В случае плоской границы среды с вакуумом дисперсия поверхностных П. определяется соотношением

$$\frac{k^2c^2}{\omega^2} = \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon(\omega)-1} \cdot \epsilon(\omega) \leq -1. \quad (2)$$

При больших значениях k ($k \gg \omega/c$) поверхностный П. переходит в поверхностный фотон, частота к-рого $\omega_{\text{пф}}$ (рис. 1) определяется из условия $\epsilon(\omega_{\text{пф}}) = -1$. В рассмотренной выше модели, отвечающей соотношению (1), $\omega_{\text{пф}}$ определяется соотношением

$$\frac{\omega^2}{\omega_{\text{пф}}^2} = \frac{\epsilon_0+1}{\epsilon_\infty-1} \cdot \frac{\omega^2}{\omega_0^2}. \quad (3)$$

Дисперсия поверхностных П. показана на рис. 1 пунктирной кривой 6.

Рассмотренная на примере фононных П. общая картина формирования П. и их характерные особенности

присущи любым П. Отличия могут быть обусловлены особенностями спектров возмущений среды, взаимодействующих с фотонами. Такой особенностью в случае экситонных П. является дисперсия пространственная, к-рая может быть значительной благодаря малости эфф. массы m^* экситона, а это приводит к зависимости от k их энергии $\epsilon_k^* = \hbar\omega_k$. В простейшем случае квадратичной зависимости (параболич. зоны, см. Зонная теория)

$$\omega_k(\epsilon) = \omega_0 + \hbar^2 k^2 / 2m^*. \quad (4)$$

Дисперсия экситонного П. (без учета затухания) вблизи изолоидов экситона в кубич. кристалле и в этом случае определяется ф-лой (1):

$$\left(\frac{kc}{\omega}\right)^2 = \frac{\omega_L(\epsilon) - \omega^*}{\omega(\epsilon) - \omega^*} \epsilon_\infty. \quad (5)$$

Здесь ω_0 , ω_L — частоты поперечного и продольного экситонов, зависящие от k . Дисперсия экситонных П. показана на рис. 3 сплошными кривыми 1 и 2; дисперсия фотонов (3) и экситонов (4) без учета взаимодействия — штриховыми. На частотах выше $\omega_L(0)$ в кристалле могут одновременно распространяться две одинаково поляризованные волны, что является следствием пространств. дисперсии. Дисперсия поверхностных экситонных П. показана пунктирной кривой 6, штриховой линией 5 — дисперсия фотонов в вакууме.

Впервые выражение для спектра П. получено К. Б. Толмого (1950) и Хуан Куем (Huang Kueh, 1951) в рамках классич. теории диэлектрического диэлектрика.

Измерение дисперсии экситонных П. в рамках классич. теории диэлектрического диэлектрика. Измерение дисперсии экситонных П. впервые осуществлено в экспериментах Д. Фрэйлиха (D. Fröhlich, 1971) с сотрудниками по двухфотонному поглощению света. Квантовомеханич. рассмотрение П. дано У. Фано (U. Fano, 1956) и Дж. Хоффилдом (J. Hopfield, 1958). Эксперим. измерение дисперсии фононных П. выполнено Ч. Генри (Ch. Henry) и Дж. Хоффилдом (1965), а также С. Порто (S. Porto) с помощью комбинационного рассеяния света под малыми углами. Измерение дисперсии экситонных П. впервые осуществлено в экспериментах Д. Фрэйлиха (D. Fröhlich, 1971) с сотрудниками по двухфотонному поглощению света.

Изучение поверхностных П. началось в связи с исследованием распространения радиоволн [Дж. Цервек (J. Zenneck), 1907, А. Зоммерфельд (A. Sommerfeld), 1909]. Эксперим. проявление поверхностных эл.-магн. волн на границе металла обнаружено Р. Вудом (R. Wood, 1912) в виде т. н. решеточных аномалий Вуда, их интерпретация в терминах поверхностных плазмонных П. дана У. Фано (1941).

Представление о П. послужило основой для интерпретации и предсказания ряда оптич. явлений. Значит, дисперсия П. позволяет, в частности, проводить спектроскопич. исследования как в частотном пространстве, так и в пространстве волновых векторов.

Лит.: Борн М., Хуан Куэнь, Динамическая теория кристаллических решеток, пер. с англ., М., 1958; Агранович В. М., Григорьев В. Л., Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов, 2 изд., М., 1979; Mills D. L., Burstein E., Polaritons the electromagnetic modes of media, «Kerpts Progr. Phys.», 1974, v. 37, p. 817; Веккер С. И., Кристаллооптика и дополнительные световые волны, К., 1982; Экситоны, под ред. Э. И. Рабца, М. Д. Стрелца, пер. с англ., М., 1985; Поверхностные поляритоны, под ред. В. М. Аграновича, Д. Л. Мильса, М., 1985.

Ю. И. Домошнев, ПОЛЯРНЫЕ РАДИОТРАЖЕНИЯ (радиоавтора) — явление рассеяния УКВ от неоднородной низованной

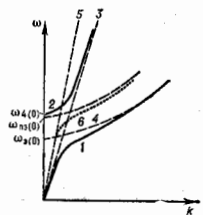
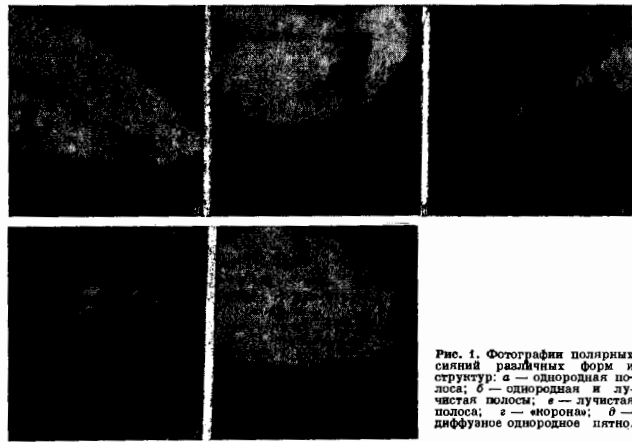


рис. 3. Дисперсионные кривые для экситонных поляритонов.

среды на высотах 100—130 км (см. *Ионосфера*) в зоне *полярных сияний* во время геомаг. возмущений (см. также *Земной магнетизм*). С помощью П. р. можно регистрировать слабые диффузные полярные сияния, не наблюдаемые оптич. методами. Причина возникновения П. р. (как и полярных сияний) — вторичные заряды, часть из *магнитосферы Земли* в ионосферу вблизи полюсов. Однако для появления П. р. необходимо ещё и наличие ионосферного электрич. поля ≥ 20 мВ/м. При более низкой величине электрич. поля неоднородности ионосферы, ответственные за рассеяние УКВ, не генерируются и П. р. не наблюдаются.

ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ — свечение верхних слоёв атмосферы, вызванное возбуждением атомов и молекул на высотах 90—1000 км потоками электронов и протонов с энергиями от сотен эВ до десятков кэВ, вторгающихся в атмосферу из космоса. В видимой области спектра оно наблюдалось на протяжении веков, с появлением же спутников и ракет наблюдения П. с. расширились в ИК-, УФ- и рентгеновую области спектра. П. с. —



частью интенсивностью от 1 до десятков Кралея вызываются концентриров. вторжениями пучков электронов, ускоренных к Земле электрич. полем вдоль магн. силовых линий. Исследования П. с. показали, что частота их появления и интенсивность, особенно в ср. широтах, явно коррелируют с активностью Солнца.

П. с. характеризуются в каждый данный момент разнообразием и причудливостью форм, к-рые в первом приближении можно подразделить на ряд элементарных форм: малоподвижные однородные дуги и полосы в виде длинных лент (рис. 1, а), протянувшихся по небосводу на сотни и иногда тысячи км; лучистые формы со значит. вертикальной протяжённостью в виде отд. лучей, пучков лучей или целых занавесей (рис. 1, б, в); «корона», лучи к-рой вытянуты вдоль силовых линий геомаг. поля и поэтому сходятся в перспективе в т. н. точке магн. зенита (рис. 1, г); диффузное свечение в виде пятен (рис. 1, д) или однородной поверхности — т. н. вуаль. Если П. с. слабое, оно воспринимается человеческим глазом как серо-зеленоватое, если яркое, — наблюдается игра красок и оттенков красного, зелёного, пурпурного и фиолетового цветов.

Кол-во дней с П. с. увеличивается при переходе от средних к высоким широтам. В ср. широтах П. с. появляются только в периоды магн. бурь. Макс. число дней с П. с. достигается в геомаг. широте $\varphi \sim 67^\circ$, в более высоких широтах — значительно меньше. Т. о., макс. изохама (линия на поверхности Земли, вдоль к-рой П. с. наблюдаются каждый день) располагается над центральной Аляской, сибирским побережьем Сев. Ледовитого ок., пересекает полуостров Таймыр, северную оконечность Скандинавии, юг Исландии и южную оконечность Гудзонова залива в Канаде. Согласно наблюдениям с помощью автоматич. камер, дискретные формы П. с. существуют практически постоянно вдоль овалов П. с., к-рые по одному в Северном и Южном полушариях фиксированы относительно направления на Солнце и как бы «висят» в пространстве над вращающейся Землей, располагаясь асимметрично геомагн. полюсу — на $\varphi \sim 77^\circ$ в дневном секторе и $\varphi \sim 87^\circ$ в ночном (рис. 2), постепенно изменяя широту в утреннем и вечернем секторах. С высот ~ 10000 км со спутников получены фотографии области свечения П. с. во всей области высоких широт (рис. 3). Овал располага-

рис. 1. Фотография полярных сияний различных форм и структур: а — однородная полоса; б — однородная и лучистая полоса; в — лучистая полоса; г — «корона»; д — диффузное однородное пятно.

о валов П. с., к-рые по одному в Северном и Южном полушариях фиксированы относительно направления на Солнце и как бы «висят» в пространстве над вращающейся Землей, располагаясь асимметрично геомагн. полюсу — на $\varphi \sim 77^\circ$ в дневном секторе и $\varphi \sim 87^\circ$ в ночном (рис. 2), постепенно изменяя широту в утреннем и вечернем секторах. С высот ~ 10000 км со спутников получены фотографии области свечения П. с. во всей области высоких широт (рис. 3). Овал располага-

конечный результат сложных процессов в околоземном пространстве, где происходит ускорение заряд. частиц, к-рые обычно называют авроральной ч. радиацией или авроральными частицами. Соударения энергичных частиц с атомами и молекулами газов верхней атмосферы приводит к возбуждению последних. Возврат в равновесное состояние сопровождается излучением квантов характерных длин волн, т. е. появляется П. с. Спектроскопич. измерения позволяют судить о величине энергии вторгающихся частиц, т. к. эфф. сечения возбуждения эмиссий поразному зависят от энергии частиц, а эффективность гашения зависит от частоты соударений, т. е. от высоты. Кроме того, глубина проникновения корпускул в атмосферу непосредственно связана с их энергией. Особенности спектра дают сведения о темп-ре слоёв атмосферы, к-рые пересекают корпускулы, их плотности и составе, степенн ионизации и ветрах на этих высотах.

Однородное высыпание авроральной радиации в верхнюю атмосферу вызывает диффузное свечение, к-рое несёт ося. долю энергии, поглощаемой верхней атмосферой, и создаёт однородный светящийся фон. На этом фоне возникают яркие разноцветные подвижные и вспыхивающие занавеси и лучи, дуги, полосы и пятна, к-рые обычно и наз. П. с. Эти дискретные формы све-

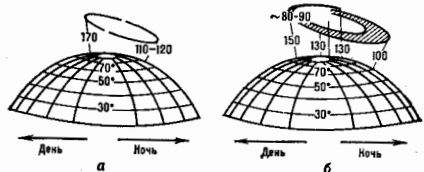


рис. 2. Овалы полярных сияний над поверхностью Земли: а — в виде узкого кольца в магнитоскопичные периоды и б — в виде заштрихованной области в магнитоскопичные периоды. Цифрами указаны высоты овалов над поверхностью Земли.

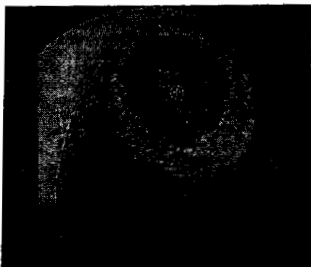


Рис. 3. Фотография овала полярных сияний в Северном полушарии (крестиком обозначен геомагнитный полюс).

ется в пределах полосы диффузного аврального свечения, охватывающей также область широт к полюсу и к экватору от овала. Это слабое субвизуальное (ниже порога чувствительности глаза) свечение с интенсивностью ≥ 10 Рэлея.

В магнитоспокойные интервалы овал П. с. очень узок; во время магн. возмущений он существенно расширяется, особенно на ночной стороне. Полярное диффузное свечение распространяется далеко к полюсу от овалов в магнитоспокойные интервалы, но прижимается к овалу в виде узкой полосы во время возмущений. Вспокойные периоды в т. н. полярной шапке появляются ориентированные на Солнце дуги полярных сияний. Диффузное субвизуальное авральное свечение распространяется и к экватору от овала.

Исследование спектра П. с. показало, что он состоит из атомарных эмиссий, так и на систем полос нейтрального и ионизированного молекулярного азота и кислорода. Наиб. интенсивны эмиссии атомарного кислорода с длинами волн $\lambda = 557,7$ нм (зелёная линия) и $\lambda = 630-636,4$ нм (красный дублет) ионизированного молекулярного азота в эмиссиях 391,4; 427,8 и 522,8 нм (ближняя УФ-; фиолетовая и зелёная части спектра). Эмиссии кислорода соответствуют метастабильным состояниям со временем жизни соответствующих возбуждённых атомов 0,74 и 110 с. Поэтому красный дублет возбуждается только на высотах 150-400 км, где замедленно протекают процессы дезактивации возбуждённых атомов кислорода. В высотных П. с. (т. н. тип А) этот дублет доминирует. П. с. на сравнительно небольших высотах (80-90 км), где из-за гашения интенсивности зелёной и красной линий понижены, с развитыми системами молекулярных полос относятся к типу В. Дневной и ночной участки овала П. с. располагаются на равных высотах над поверхностью Земли — 150-170 км днём и 100-120 км ночью. Это объясняет преобладание атомарных эмиссий в дневном секторе овала и появление полос молекулярных эмиссий заметной интенсивности в ночном.

Вторжения ионов водорода приводят к появлению в секторе П. с. эмиссий *Бальмера серии*. Наиб. интенсивна (до кРэлея) линия H_{α} с $\lambda = 656,3$ нм. Протоны, двигающиеся к Земле вдоль магн. силовых линий, нейтрализуются в результате процессов перезарядки уже на высотах в сотни км и движутся дальше как нейтральные атомы водорода. Возбуждаются при столкновениях, эти атомы затем излучают, причём линия их спектра оказывается сдвинутыми по длине волны в результате *Доплера эффекта*. По сдвигу линии можно определить направление движения атомов и их энергию. Излучение сосредоточено на высотах более 130 км и обусловлено вторжением протонов с энергиями 1-100 кэВ. В вечернем секторе оно располагается к экватору от овала в виде слабой светящейся полосы про-

тяжённостью в неск. сотен км по широте. В П. с. наблюдаются также спектральные линии гелия. Эмиссия He с $\lambda = 388,9$ нм является характерной особенностью П. с. в полярной шапке.

Сектр П. с. меняется с широтой. В ср. широтах обычно преобладают красные сияния типа А, на широтах зоны П. с. в почные часы — обычный (смешанный) тип, а также сияния типа В, в полярной шапке — сияния типа А. В приполюсной области после интенсивных хромосферных всплесков на Солнце возникает равномерное свечение полярной шапки в полосах нейтрального и ионизированного азота, к-рое обусловлено непосредств. вхождением в атмосферу солнечных протонов с энергией 1-100 МэВ, проникающих до высот 20-100 км.

Планитарная картина распределения аврального свечения связана со структурой магнитосферы, с геометрией геомагн. поля и распределением в магнитосфере авральной плазмы. Асимметричное расположение овала П. с. относительно геомагн. полюса обусловлено сжатием магнитосферы *солнечным ветром* на дневной стороне и образованием магн. хвоста на ночной. На рис. 4 приведены структурная схема расположения плазменных доменов в магнитосфере (рис. 4, а) и связь

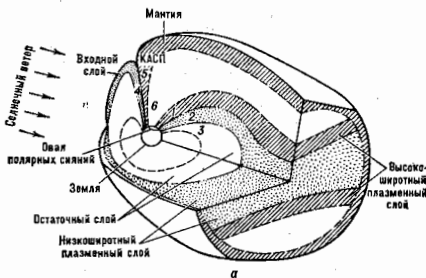


Рис. 4. а — Структурная схема основных плазменных доменов в магнитосфере Земли, к-рая рассеяна вертикальной плоскостью полдень — полдень и экваториальной плоскостью утро — вечер, а также плоскостью поперёк хвоста магнитосферы.

их с разл. типами аврального свечения на высотах земной атмосферы (рис. 4, б). Для выявления внутренней структуры магнитосферы рассеяна вертикальной плоскостью полдень — полдень и экваториальной плоскостью утро — вечер, а также плоскостью поперёк хвоста магнитосферы. На рис. 4(б) обозначены типы аврального свечения цифрами 1-3 на ночной стороне и цифрами 4, 5 на дневной стороне. Эти же цифры даны на сечении магнитосферы. Показано, как какие структурные

б — Типы аврального свечения на высотах верхней атмосферы в увеличенном масштабе. На ночной стороне: 1 — приполюсное диффузное свечение, 2 — овал полярных сияний, 3 — экваториальное диффузное свечение. На дневной стороне: 4 — овал полярных сияний, 5 — приполюсное диффузное свечение, 6 — полярная шапка.

плазменные образования в магнитосфере проектируются разл. типы аврального свечения. Овал П. с. 2 и 4 проектируется на низкоширотную (главную, центральную) часть плазменного слоя на ночной стороне Земли и на входной слой вблизи границы магнитосферы на дневной стороне. Экваториальное диффузное свечение 3 проектируется в магнитосферу на остаточный слой, в к-рый авральные электроны с ϕ_e от 1 кэВ переносятся из плазменного слоя под действием скрещённых электрич. и магн. полей. Полярное диффузное свечение 1 и 5 проектируется на высокоширотную грани-

ную область плазменного слоя. Дуги полярной шапки δ , ориентированные на Солнце, погружены в полярное диффузное свечение и, следовательно, проектируются на расширенный (в спокойных условиях) плазменный слой хвоста либо на расширенный пограничный слой (магнито). В дневном секторе диффузное свечение 5 км полукругом от овала проектируется на плазменную магнито и воронку каспа. Оно обусловлено вторжением частиц небольших энергий, непосредственно проникающих в эту область из солнечного ветра.

Планетарная картина развития П. с. может быть разделена на отд. серии интенсивных вспышек свечения, начинающихся на ночной стороне и постепенно охватывающих всю область высоких широт. Продолжительность их от неск. мин до десятков мин с общей длительностью серии до 1—2 ч (т. н. авроральные суббури). Авроральная суббуря является частью суббури в магнитосфере, связанной с увеличением втекающего в магнитосферу потока энергии из солнечного ветра и частичной диссипацией энергии магн. поля, западной в хвосте магнитосферы. В период суббури в верхней атмосфере при торможении авроральных электронов образуются интенсивные потоки рентг. лучей, к-рые являются более проникающими, чем авроральные электроны. Они достигают высот 30—40 км, где их можно зарегистрировать аппаратурой на высотных аэростатах. При быстрых сверхзвуковых движениях П. с. и связанных с ними мощных ионосферных токах возникают инфразвуковые волны с периодами от 10 до 100 с, достигающие нижних слоёв атмосферы.

Телевизионная техника позволила установить сопряжённость П. с. в двух полушариях, исследовать быстрые изменения и тонкую структуру П. с. Наряду с изучением естеств. П. с. были поставлены эксперименты по созданию искусств. П. с., во время к-рых с ракеты на высоте неск. сотен км инжектировался в атмосферу пучок электронов высоких энергий. Измерения интенсивности отд. эмиссий и фотографирование П. с. из космоса проводятся со спутников как на полярных круговых орбитах с высот ~ 400—1000 км, так и на экваториальных орбитах с апогеем ~ 10^4 км. Использование свечения в крайнем ультрафиолете, излучаемого на высотах ≥ 110 км, позволяет вести наблюдения П. с. также и в областях атмосферы, освещённых прямыми солнечными лучами. Т. о., со спутников осуществляется непрерывная регистрация свечения верхней атмосферы, его распределения в области высоких широт и интенсивности. Результаты используются для диагностики эл.-магн. состояний ближнего космоса.

Лит.: Чемберлен Д. Дж., Физика полярных сияний и излучения атмосферы, пер. с англ., М., 1963; Акасоф У. С.-И., Полярные и магнитосферные суббури, пер. с англ., М., 1971; Исаев С. И., Пулковский И. И., Полярные сияния и процессы в магнитосфере Земли, Л., 1972; Омхольт А., Полярные сияния, пер. с англ., М., 1974; Полярная верхняя атмосфера, под ред. Ч. Дирра, Я. Холмста, пер. с англ., М., 1983; The solar wind and the Earth, ed. by S.-I. Akasofu, G. Kampe, Tokyo, 1987; Лайонс Л., Уильямс Д., Физика магнитосферы, пер. с англ., М., 1987.

ПОЛЯРОИД — один из типов оптич. линейных поляризаторов, действие к-рого основано на явлении линейной дихроизма — сильного преимуществ. поглощения одной из линейно поляризованных компонент оптич. излучения. П. представляет собой тонкую поляризующую плёнку, заключённую в пленку между двумя прозрачными пластинками (пленками). Дихроизм П. обусловлен дихроизмом мельчайших кристалликов или молекул полимера, введённых в прозрачную матрицу (из стекла или пластмассы) и пространственно односторонне ориентированных в ней. Ориентацию осуществляют с помощью растяжения плёнки, сдвиговых деформаций или иной спец. технологии. Достоинствами П. являются его высокая рабочая угл. апертура (до 80°) и компактность, недостатками — относительно низкая стоимость и воздействия влаги и темп-ры, невысокое пропуска-

ние (~30%), спектральная селективность и низкая лучевая прочность, из-за чего П. нельзя использовать в достаточно мощных лазерных пучках.

П. применяются для регулировки интенсивности света (напр., в очках, спектрофотометрах, фарах автомобиля), получения стереоскопического изображения.

В. С. Зитаский (одежды) «шубой» виртуальным

ПОЛЯРОН — носитель заряда (для определённости — электрон), окружённый фононами, способный перемещаться вместе с ней по кристаллу. Электрон-фононное взаимодействие приводит наряду с обычным рассеянием электрона на фононах (см. Рассеяние носителей заряда) также к изменению энергетич. спектра электронов (поляронный эффект). Появление «П.» введено С. И. Лекаром (1946), к-рый предложил первую модель П., основанную на взаимодействии электрона проводимости с длинноволновыми продольными оптич. фононами в ионных кристаллах [1]. Механизм этого взаимодействия элестростатический. Продольные оптич. колебания ионной решётки (см. Колебания кристаллической решётки) сопровождаются волной элестрич. поляризации, и создаваемое ею элестрич. поле действует на электрон. Вследствие термина «П.» приобрёл более широкий смысл и применяется к электрону, взаимодействующему с любыми фононами, а также с магнами и др. квазичастицами.

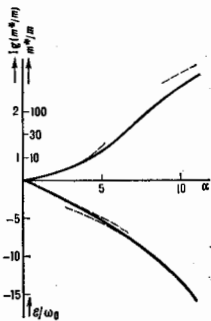


Рис. 1. Энергия E и эффективная масса m^* поларона большого радиуса в функции константы связи ϵ ; сплошные кривые — радиационный расчёт, штриховые — по формулам (4), (6).

поляризации, и создаваемое ею элестрич. поле действует на электрон. Вследствие термина «П.» приобрёл более широкий смысл и применяется к электрону, взаимодействующему с любыми фононами, а также с магнами и др. квазичастицами.

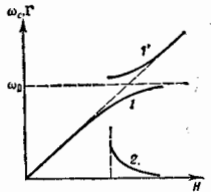


Рис. 2. Магнетофононный резонанс в энергетическом спектре поларона. Кривые 1 и 1' — дисперсионная частота ω и функция магнитного поля H ; 2 — затухание Γ состояния ω_0 за счёт испускания оптического фонона.

Поляризац. электрон-фононное взаимодействие электрона с оптич. фононами описывается гамильтонианом

$$\mathcal{H} \approx \sum_q (\alpha' \mathbf{1} / q) \left[\exp(iqr) b_q + \exp(-iqr) b_q^\dagger \right], \quad (1)$$

где b_q , b_q^\dagger — операторы уничтожения и рождения фонона с волновым вектором q , r — пространств. координата электрона. Коэф. α , наз. фрёдлиховской константой связи, равен [2]:

$$\alpha = (m/2\hbar^2\omega_0^{1/2}) \int_0^\infty \langle e^2 \rangle / \epsilon; \quad \epsilon^{-1} = \epsilon_\infty^{-1} - \epsilon_0^{-1}. \quad (2)$$

Здесь m — эффективная масса электрона, ω_0 — частота продольных оптич. ДВ-фононов (при $q=0$), ϵ_0 — статич. диэлектрическая проницаемость, ϵ_∞ — диэлектрич. ВЧ-проницаемость (электронный вклад).

В зависимости от величины α различают случаи слабой ($\alpha < 1$), промежуточной ($\alpha \sim 1$) и сильной ($\alpha \gg 1$) электрон-фононных связей.

Полярон сильной связи. При $\alpha \gg 1$ поляризация решетки является статической, она создает потенциал, захватывающий электрон на локальный уровень, а электрон своим электрич. полем поддерживает поляризацию, т.е. возникающее состояние является самосогласованным. Ур-ние Шрёдингера для П. имеет вид [1-3]:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi - \frac{e^2}{\epsilon} \int d\mathbf{r}' \frac{|\Psi(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \Psi(\mathbf{r}) = \epsilon_0 \Psi(\mathbf{r}), \quad (3)$$

где ϵ_0 — энергия электрона в поле решетки.

Поляризация решетки выражается через $\Psi(\mathbf{r})$: $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = D(\mathbf{r})/4\pi\epsilon$, где $D(\mathbf{r})$ — электростатич. индукция, создаваемая электрич. зарядом с плотностью $-e|\Psi(\mathbf{r})|^2$. Энергия электрона в поле решетки $\epsilon_0 < 0$, а полная энергия П., включающая энергию поляризации решетки, равна $\epsilon = \epsilon_0/3$. Ур-ние (3) описывает автолокализ. состояние электрона с радиусом локализации $r_{\text{эл}} \sim \hbar^2 \epsilon / m e^2$ (см. Автолокализация).

Ур-ние (3) справедливо, если $r_{\text{эл}}$ значительно больше постоянной решетки (П. больше ω_0 радиуса). Энергия $|\epsilon_0| \sim m e^4 / \hbar^2 \epsilon^3 \sim \alpha^2 \omega_0$, и условие применимости адаптич. приближения, когда электрон движется в поле неподвижной решетки, $|\epsilon_0| \gg \hbar \omega_0$. При этом применима теория сильной связи, в к-рой параметром резонанса является $\alpha^2 \ll 1$.

Из-за взаимодействия фононов с автолокализов. электроном вблизи П. изменяется фононный спектр, т.е. образуются локальные фононные моды с частотами $\omega < \omega_0$. Их возбуждение соответствует образованию связанных состояний П. с фононами [4]. Три частоты фононов обращаются в нуль, что означает возникнове-ние 3 трансляционных степеней свободы П. Энергия П.

$$\epsilon \approx - (0,1085\alpha^2 + 2,836)\hbar\omega_0, \quad (4)$$

его эфф. масса

$$m^* \approx 0,023\alpha^2 m. \quad (5)$$

Быстрый рост m^* с увеличением α объясняется тем, что движение П. сопровождается перемещением его поляризац. «шубы». Ур-ние (3) кроме осн. состояния П. описывает также возбужденное автолокализ. состояние. Опич. переходы между ними являются причиной поглощения света на частотах $\omega \sim \epsilon_0/\hbar$.

Полярон слабой связи. При $\alpha \ll 1$ свойства П. описываются с помощью теории возмущений, что приводит к Ф-лам

$$\epsilon \approx -\alpha\hbar\omega_0, \quad m^* \approx m(1-\alpha/6). \quad (6)$$

Ф-лы для энергии (4), (6) «сшиваются» при $\alpha \sim 5$ (рис. 1). При промежуточной связи теория основывается на вариац. методах [5].

Подвижность П. μ при $\alpha \approx 1$ определяется их однополовыми рассеянием: $\mu \propto \alpha^1$. При $\alpha \gg 1$ рассеяние П. становится двухфононным и при низких темп-рах $\mu \propto \alpha^2$.

При $\alpha \ll 1$ полиранный эффект проявляется в т. магнетифононном резонансе [6]. Причина явления — резонансное усиление влияния электрон-фононного взаимодействия на энергетич. спектр П. в магн. поле H при циклотронной частоте электрона $\omega_c = eH/mc \approx \omega_0$. Вблизи $\omega_c = \omega_0$ электронный спектр расщепляется на 2 ветви (рис. 2); величина расщепления $\sim \alpha^2 \omega_0$. Нижняя ветвь (1) является стационарной — «затухающая» Г = 0. Состояния, соответствующие верх. ветви (1'), являются затухающими (распадающимися), для них $\Gamma \sim \alpha^2 \omega_0$ при $\omega_c \approx \omega_0$ и быстро убывает с ростом ω_c . Вблизи $\omega_c \approx \omega_0$ изменяется волновая ф-ция П.: «вали» от резонанса число виртуальных фононов в «шубе» электрона $N \propto \alpha$, а в резонансе $N \approx 1/2$. Магнетифононный резонанс наблюдается по расщеплению линий

циклотронного резонанса и комбинированного резонанса, а также по межзонному поглощению света в магн. поле. Он позволяет измерять α . Др. проявление полярного эффекта — плавная зависимость $m^*(H)$, определяемая из циклотронного резонанса: $m^* = eH/\hbar\omega_c$. С ростом H масса П. m^* растёт тем быстрее, чем больше α .

Величина α при $m \approx m_0$ и $\bar{\epsilon} \approx 1$ (m_0 — масса электрона в вакууме) велика: $\alpha \approx (e^2/\hbar\omega_0) \approx 10$ ($|F_{\text{эл}}| \approx 10$ эВ — энергия электрона в атоме). Но т. к. в кристаллах часто $m \ll m_0$, $\bar{\epsilon} \gg 1$, то $\alpha \approx 1$ либо $\alpha \ll 1$. Поэтому П. слабой связи возникают во мн. веществах (табл.).

Полярон малого радиуса. Если $m^* \sim m_0$ и связь сильная, то П. сосредоточен на 1-2 узлах кристаллич. решетки (П. малого радиуса). Такой П. (дырочный или электронный) взаимодействует преим. с КВ-фононами (акустическими и оптическими). Его энергия $|E| \gg \epsilon_0$, где ϵ_0 — ширина разрешённой электронной зоны в кристалле с деформирован. решеткой. Спектр П. имеет зонную структуру. Ширина полярной зоны $E_{\text{пл}} = \epsilon_0 \exp(-S_0)$, где $S_0 \sim |\Psi|/\hbar\omega_0 \gg 1$, т.е. она крайне узка, а m^* столь же велика.

В совершенном кристалле при низких темп-рах полярная проводимость (носители заряда — П.) является зонной, во примесях и дефектах легко разрушают циклотронную зон. С ростом T она быстро сужается, т.к. $S(T) = S_0 \text{th}(\hbar\omega_0/2kT)$, и зонный механизм проводимости сменяется и р-ж к о в м (см. Прямая проводимость). В классич. области коэф. диффузии П. $D \approx \exp(-E_{\text{акт}}/kT)$, где $E_{\text{акт}} \approx |E_{\text{пл}}|$ — энергия активации. Дырочные П. в щелочно-галогидных кристаллах и отвержденных благородных газах являются молекулярными ионами типа Cl_2^+ и Ar_2^+ [6].

Неполяризованные электрон-фононные взаимодействия. В трёхмерном случае электрон, взаимодействующий с акустич. фононами, либо не автолокализуется, либо образует П. малого радиуса (это энергетич. состояние отделено от зонного состояния электрона автолокализ. барьером). Напротив, в одномерной системе возможно существование П. большого радиуса, причём он образуется из зонного состояния электрона «безбарьерно» [7]. Ур-ние Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} - d\Psi^2(x) = \epsilon_0 \Psi(x) \quad (7)$$

в этом случае имеет точное решение (см. Шрёдингера уравнение нелинейное). В случае взаимодействия с опич. фононами $g = 2\hbar\alpha(2\hbar\omega_0/m)^{1/2}$ и $\Psi(x) = (b/2)^{1/2} \text{sech}(bx)$, $b = \alpha(2m\omega_0/\hbar)^{1/2}$, $\epsilon_0 = -\alpha^2 \omega_0$, где $\alpha \gg 1$ — константа связи. Ф-лы, аналогичные (4) и (5), имеют вид:

$$\epsilon \approx -\left(\frac{1}{3}\alpha^2 + 0,955\right)\hbar\omega_0, \quad m^* = \frac{32}{15}\alpha^2 m, \quad (8)$$

Константа α выбрана так, что при слабой связи $\epsilon \approx -\alpha\hbar\omega_0$, как и в (6). Переход к сильной связи происходит при $\alpha \approx 1,5$, т.е. равнее, чем для трёхмерного П.

Наиб. изучены проводящие полимеры типа полиацетилен (C_2H_2) с сопряжёнными связями (см. Квазиодномерные соединения). В нек-рых из них осн. дисперсия. состояние системы возникает вследствие Пайерса перехода, создающего чередующуюся последовательность одинарных и двойных связей, а в других равенность связей нарушается также и периодич.

потенциалом окружения. П. возникает за счёт того же взаимодействия с акустич. фононами, к-рое ответственно за паверловский переход. Поэтому энергия связи П. велика, сравнима с шириной запрещённой зоны (паверловская щель $\Delta \sim 1$ эВ). Радиус состояния велик — порядка 10 межатомных расстояний, поэтому применимо континуальное описание, типичное $m^* \sim 10m_0$. (Образуются также *бильроны* (2 электрона в общей деформации). Из-за паверловской природы осн. состояния П. описываются двухкомпонентным аналогом у-ряния (7) и тесно связаны с топологич. солитонами, существующими в этих материалах. Наличие этих 3 типов носителей заряда (П., бильрон, *солитон*), возможность их взаимных превращений и зависимость их отности, устойчивости от природы осн. состояния специфичны для квазидомерных систем с большой паверловской деформацией и обуславливают их электронные свойства [8].

Полароны др. типов. В магнитоупорядоченных кристаллах П. возникают вследствие взаимодействия носителей заряда с *магнонами*. Напр., в антиферромагн. кристаллах вокруг электрона может возникнуть область ферромагн. упорядочения. Магн. П. существенно влияют на свойства *полужемских полупроводников* типа $Cd_{1-x}Mn_xS(Se, Te)$. Вблизи к П. флукуты — области с изменённым параметром порядка, возникающие вокруг носителей заряда. Аналогичны поларонные эффекты, связанные с экситонами.

Лит.: 1) Пекар С. И., Локальные квантовые состояния электрона в идеальном монокристалле, «ЖЭТФ», 1946, т. 16, с. 341; 2) К и т в е л а Ч., Квантовая теория звездных тел, пер. с англ., М., 1987; 3) А п п е л ь Д. И., Ф и р с о в Ю. А., Подпороны, М., 1975; 4) Л е а н о н И. Б., Р а ш б а Э. И., Пороговые явления и связанные состояния в поларонной проблеме, «ФНТ», 1975, т. 111, в. 4, с. 483; 5) Ф е й л м а н Р., Статистическая механика, пер. с англ., М., 1978, т. 8; 6) А з у л е р Э. Д., Л у с и с Д. Ю., Ч е р н о в С. А., Электронные возбуждения и радиолокационные щелочно-галогенных кристаллов, Физ., 1979, т. 9, в. 6 а, Э. И., Автолокализация экситонов, в кн.: Экситоны, М., 1985, т. 13; 7) В е с с е т А. J. и др., Solitons in conducting polymers, «Rev. Mod. Phys.», 1988, т. 60, p. 781.

ПОЛЯРЫ (звёзды типа АМ Геркулеса) — *тесные двойные звёзды*, характеризующиеся наличием значит. поляризации излучения, что и получило отражение в их названии. Впервые этот эффект обнаружен С. Тапиа (S. Tapia) в 1976 у объекта АМ Геркулеса.

Известно 13 П., четыре из к-рых имеют орбитальные периоды от 81,0 до 108,5 мин, шесть — в очень узком интервале от 113,5 до 114,8 мин и три — от 185,6 до 222,5 мин. Кроме орбитальной переменности наблюдаются также более медленные изменения *блеска* с характерным временем месяца и годы (амплитуда 2—4^m) и быстрая переменность с характерным временем 1—10 с (амплитуда 0,1—0,3^m). Вследствие селекции число известных П. составляет $\approx 1/3$ от общего числа потенциально наблюдаемых объектов этого типа.

Группа П. выделяется среди др. катализмич. переменных (см. *Переменные звёзды, Новые звёзды*) наличием ряда характерных свойств: излучение в оптической и ближней ИК-области сильно поляризовано (степень поляризации у нек-рых П. доходит до 35%), причём поляризация меняется с тем же периодом, что и блеск и *лучевые скорости*; в спектре наблюдаются эмиссионные линии водорода, гелия и др. элементов, причём «ядра» и «крылья» линий могут изменяться по обязательно синфазно; наблюдается рентг. и УФ-излучение, распределение энергии в спектре обычно имеет локальные максимумы в жёстком и мягком рентг. диапазонах, а также в оптической или ближней ИК-области. Второе и третье свойства характерны также для др. (нематричных) катализмич. переменных (КП). Наличие поляризации само по себе не может свидетельствовать о принадлежности к П., необходима синхронность (но не синфазность) изменения всех характеристик излучения.

Ультракороткопериодч. двойная система, образующая П., состоит из невырожденного спутника, являющегося

своею *полостью Роша*, и *белого карлика* (орбитальное и вращательное движения к-рого синхронны) с сильным (10^7 — 10^8 Гс) магн. полем. Массы спутников приблизительно пропорциональны орбитальному периоду и составляют $0,14$ — $0,45 M_{\odot}$, а их *спектральные классы* M4III и более поздние. Массы белых карликов, по косвенным данным, составляют $0,6$ — $1,2 M_{\odot}$. Размеры магнитосферы r_m белого карлика превосходят расстояние между компонентами a , и истекающие из неё окрестности внутр. точки Лагранжа шество обло-чек спутника движется вдоль магн. силовых линий. Такой объект наз. магнитной тесной двойной системой (МТДС), в отличие от объектов с $r_m \lesssim a$. Для анализа удобно выделить три осн. зоны движения вещества, к-рые показаны на рис. 1.

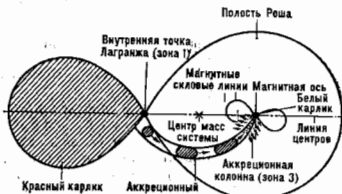


Рис. 1. Схема поляр.

В первой зоне структура истекающей из обложки спутника струи плазмы зависит также от направления магн. поля. Скорость аккреции (кол-во перетекающего вещества за единицу времени) максимальна, если магн. осн. белого карлика направлена вдоль линии центров, и практически равна нулю, если эти осн. перпендикулярны друг другу. Т. о., изменения светимости в неск. десятков раз с характерным временем месяца и годы могут быть объяснены изменениями ориентации магн. осн. белого карлика. Кроме того, на скорость аккреции влияют активность звезды-спутника (подобная солнечной), доплитер. прогрез обложки спутника рентг. и УФ-излучением белого карлика, а также малые флукутации расстояния между звёздами под действием возможного третьего тела типа Юпитера.

Вторая зона наиб. протяжённая, и именно здесь осуществляется эфф. передача момента импульса аккрецирующей плазмы белому карлику, определяющая как траекторию движения самого вещества, так и энтопию вращат. движения белого карлика. Взаимодействие магн. поля белого карлика с обложкой спутника и аккрецирующей плазмой приводит к быстрой ($t_m \sim 10^3$ лет) синхронизации орбитального и вращат. движений белого карлика, к-рая является наиб. удивительной особенностью П., отличающей их от множества др. КП с быстро вращающимися белыми карликами, а также от двойных систем с нейтронными звёздами. Асинхронные МТДС (время жизни $t < t_m$) находятся на т. н. стадии проллера: вещество выбрасывается за пределы магнитосферы дополнительной центробежной силой, возникающей при движении вещества вдоль быстро вращающихся магн. силовых линий белого карлика. Такие объекты классифицируются как IIIр, в отличие от классич. П. (IIIм), и на этой короткой стадии могут наблюдаться как радиосточники. Примером системы с быстро синхронизирующимися белым карликом является V 1500 Лебедя, вспыхнувшая в 1975 как классическая новая. В объектах, у к-рых $r_m < a < a$ (где r_m — радиус белого карлика), присутствует как аккрец. диск, так и аккреция в окополарных области. Они наз. «промежуточными П.» (IIIа), поскольку частично обладают свойствами как МТДС,

так и магнит. КП. Объекты, у к-рых $r_0 \approx r_0$, являются магнит. КП — новыми, повторными новыми, карликовыми новыми и новоподобными звездами. Вблизи положения равновесия возможны циклические (не строго периодические ввиду неустойчивости характеристик оболочки спутника) изменения ориентации магн. оси белого карлика относительно линии центров с характерными временами 1—10 лет, что приводит к циклич. перемены фазовых кривых изменения потока, поляризации и лучевых скоростей. В пользу такой модели «качающегося диполя» свидетельствуют также корреляции светимости и смещения кривых блеска по фазе. При достаточно большой скорости аккреции белый карлик вращается не совсем синхронно, делая один оборот относительно спутника за нек. лет. Однако «переключения» аккреции с одного полюса на другой, к-рые должны были бы наблюдаться в этом случае, до сих пор не обнаружены ни у одного из П. Наблюдаемая же иногда аккреция одноврем. на 2 полюса может объясняться и в рамках модели «качающегося диполя».

Третья зона — аккрец. колонна (АК) между поверхностью белого карлика и аккрец. потоком (рис. 2) — является осн. источником излучения П., доминирующим над излучением звездных компонентов. Аккрец.



Рис. 2. Схематическое изображение основных источников изменения поляра.

поток, движущийся вблизи белого карлика со скоростью нек. тысяч км/с, ударивается с плазмой в АК и тормозится, образуя ударную волну. В процессе дальнейшего падения плазма охлаждается от 10^8 до 10^6 К а за счет рентг. тормозного и оптич. циклотронного излучения. Возможно также протекание термоядерных реакций у основания АК. Полная мощность излучения АК может достигать 10^{38} — 10^{37} Вт.

Высота (над поверхностью белого карлика) фронта ударной волны может изменяться с характерным временем порядка нек. секунд, что может объяснить наблюдаемую быструю переменность П. Кроме того, могут существовать ещё 5 типов неустойчивости, связанных с возможными неоднородностями трёхмерной АК. Под воздействием приливных сил и магн. поля облака плазмы, истекающей из звезды-спутника, вблизи белого карлика приобретают форму «спагетти», длина к-рых в $\sim 10^4$ раз превышает их толщину. При столкновении с ударной волной в каждом из «спагетти» могут возникнуть квазипериодич. колебания структуры, продолжающиеся десятки секунд (время «пролёта» отд. «спагетти» на расстояние, равное его длине). Наблюдаемые быстрые изменения блеска ряда П., к-рые могут

быть объяснены этим механизмом, известны как феномен «шайбара».

Эволюция П., как и др. КП, определяется в осн. потерей момента импульса системой за счёт гравитационного излучения (см. *Гравитационные волны*) и, возможно, магн. звездного ветра.

Лит.: R i t t e r H., Catalogue of cataclysmic binaries, low-mass X-ray binaries and related objects, 5 ed., «Astron. Astrophys. Suppl.», 1990, v. 85, p. 1179; F r a n k J., The evolution of magnetic cataclysmic variables, Münch., 1985; L a m b D. Q., Recent developments in the theory of AM Her and DQ Her stars, в кн.: Cataclysmic variables and low-mass X-ray binaries, Dordrecht — 1991, 1985, p. 180; L i e b e r t J., S t o c k m a n H. S., The AM Herculis magnetic variables, там же, p. 151; A n d r o n o v I. L., On the mechanism of the «Noisier» phenomenon in magnetic close binary systems, «Astron. Nachr.», 1987, Bd. 308, S. 229; e r g o m e S. Winding dipoles in magnetic close binary stars, «Astrophys. Space Sci.», 1987, v. 131, p. 357; В о л х а т с к а я Н. Ф., Тесные двойные системы типа AM Геркулеса, Обзор наблюдательных данных, «САО АН СССР», 1989, № 43. Автор: Л. Андронов.

ПОМЕРАНЧУКА ТЕОРЕМА В фазике высоких энергий ψ — устанавливает асимптотич. равенство полных сечений ($\sigma_{\text{полн}}$) взаимодействия частицы a и античастицы c с одной и той же произвольной мишенью b в пределе, когда энергия E частицы стремится к бесконечности:

$$\lim_{E \rightarrow \infty} \left(\frac{\sigma_{\text{полн}}^{ab}(E)}{\sigma_{\text{полн}}^{cb}(E)} \right) = 1. \quad (1)$$

П. т. основана на свойствах аналитичности и *перекрёстной симметрии* (креслинг-симметрии) амплитуд рассеяния, к-рые вытекают из общих принципов квантовой теории поля, а также на естеств. физ. предположениях: 1) амплитуды $T(\psi)$ не являются осциллирующими функциями при $E \rightarrow \infty$; 2) $\lim_{E \rightarrow \infty} \frac{\text{Re } T(\psi)}{\text{Im } T(\psi)} \ln(E/E_0) \rightarrow 0$ при $E \rightarrow \infty$ (E_0 — энергия порядка энергии покоя рассеиваемой частицы).

Эта теорема сформулирована И. Я. Померанчуком в 1958 [1] при следующих предположениях: взаимодействия адронов при высоких энергиях имеют дифракц. характер, амплитуды процессов упругого рассеяния являются $\sigma_{\text{полн}}^{ab}$ прям. и обратн. процессами, полные сечения взаимодействия $\sigma_{\text{полн}}^{ab}$ стремятся к пост. пределу при $E \rightarrow \infty$. В этом случае равенство (1) можно сформулировать как утверждение о том, что разность полных сечений взаимодействия частицы и античастицы $\Delta\sigma = \sigma_{\text{полн}}^{ab}(E) - \sigma_{\text{полн}}^{cb}(E)$ стремится к нулю с ростом энергии. Последующие эксперим. данные показали, что полные сечения взаимодействия адронов растут с увеличением энергии. Однако равенство (1) остаётся справедливым и в случае растущих полных сечений. Если $\sigma_{\text{полн}}^{ab} \rightarrow \infty$ при $E \rightarrow \infty$, то предположение 2 может быть доказано исходя из аналитичности и *унитарности условия*. П. т. исторически явилась первой из *асимптотических теорем*, к-рые следуют из весьма общих свойств релятивистской квантовой теории.

Общий метод доказательства П. т. для растущих полных сечений взаимодействия [2], а также её обобщение на дифференц. сечения процессов, связанных соотношениями креслинг-симметрии, разработаны в [3—5]. Показано, что в предположении об отсутствии осцилляций амплитуд рассеяния при $E \rightarrow \infty$ дифференц. сечения упругого рассеяния частицы и античастицы при фиксиров. значениях квадрата переданного 4-импульса t стремятся к одинаковому пределу с ростом E :

$$\lim_{E \rightarrow \infty} \left(\frac{d\sigma_{\text{уп}}^{ab}(E, t)}{dt} / \frac{d\sigma_{\text{уп}}^{cb}(E, t)}{dt} \right) = 1. \quad (2)$$

В случае произвольной двухчастичной реакции $ab \rightarrow cd$ аналогичное равенство должно выполняться

для дифференциальных сечений прямого и перекрестного $\sigma_B \rightarrow ad$ каналов при одинаковых значениях $t = (p_0 - p_0')^2$. Все эксперим. данные о полных сечениях взаимодействия адронов в дифференциальных сечениях бинарных реакций согласуются с равенствами (1), (2).

Лит.: 1) Померанчук И. Я., Равенство полных сечений взаимодействия нуклонов и антинуклонов при больших энергиях, «ЖЭТФ», 1958, т. 34, с. 725; 2) Мейман Н. И., Об асимптотическом равенстве полных сечений частиц и античастиц, там же, 1962, т. 43, с. 2277; 3) Лофелло А. А. и др., Asymptotic relations between cross section in local field theory, «Phys. Lett.», 1963, в. 7, р. 69; 4) Доглунов А. А., Негуеван Х. В. и У. Тодоров И. Т., Асимптотическое соотношение между амплитудами рассеяния в локальной теории поля, «Физматлит», 1966, т. 88, с. 5; 5) Van Hove L., An extension of Pomerenchuk's theorem to diffraction scattering, «Phys. Lett.», 1963, в. 5, р. 252. А. В. Кабдолов.

ПОМЕРАНЧУКА ЭФФЕКТ — явление темп-ры смеси твердого и жидкого ^2He при ее адиабатич. сжатии ниже темп-ры T_{II} . П. а. предсказан И. Я. Померанчуком в 1950, экспериментально обнаружен Ю. Д. Ауфрейным в 1965. П. а. обусловлен тем, что энтропия системы неупорядоченных ядерных спинов твердого ^2He остается постоянной вплоть до темп-ры Нееля T_{II} (см. Нееля точка, Антиферромагнетик), к-рая для твердого ^2He равна 1 мК, а энтропия жидкого ^2He убывает по линейному закону, характерному для ферми-жидкости (см. Квантовая жидкость). В результате ниже $T_{II} \approx 0,32$ К энтропия жидкого ^3He не становится меньше энтропии твердого ^2He , а теплота плавления ^2He — отрицательной. Согласно Клапейрона — Клаузиуса уравнению, изменению знака теплоты плавления соответствует минимум на кривой плавления, и соответственно адиабатич. сжатие находящегося в равновесии смеси жидкого и твердого ^2He приводит к понижению ее темп-ры. П. а. используется для получения сверхнизких темп-р от 10–20 мК до 1–1,5 мК.

А. С. Вороних-Рожанов.

ПОМЕРОН (полос Померанчука) — самый "правый" в комплексной плоскости угла момента J полюс Редже, определяющий в рамках Редже полюсов метода асимптотич. амплитуд рассеяния при высоких энергиях. П. имеет квантовые числа вакуума: нулевой изоспин, положительная четность и G -четность. Поскольку сигнатура П. положительна, то он даёт одинаковый вклад в амплитуды рассеяния частиц и античастиц и обеспечивает выполнение Померанчука теорем. Обмен несомкнутыми П. приводит к многопомеронным ветвлениям. Суммарный вклад полюса Померанчука и сопровождающих его ветвлений генерирует в J -плоскости особую особенность Померанчука, определяющую асимптотич. амплитуду дифракц. процессов — упругого рассеяния, дифракц. рождения частиц (см. Дифракционное рассеяние, Дифракционная диссоциация). А. В. Кабдолов.

ПОНДЕРОМОТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ СВЕТА (от лат. ponderis, род. падеж ponderis — тяжесть и motor — движущий) — механич. воздействие оптич. излучения на вещество, состоящее в передаче ему светом импульса и момента импульса и не меняющее состояние вещества (плотность, темп-ру и т. п.). Частная форма такого воздействия — давление света. Механич. действие света, связанное с зависимостью оптич. свойств вещества от плотности и внутр. напряжений, обычно не считается П. д. с. и наз. с т р и к ц и е й (см. Электрострикция).

Природа и составляющие П. д. с. наглядно выясняются на примере действия светового поля на твердую частицу с размерами, меньшими длины волны света. Световое электрич. поле с напряженностью E индуцирует в частице осциллирующий диполь с моментом p . На диполь действует электрич. поле с силой $(\nabla E)E$ и магн. поле H света с силой $[pH]/c$. Их сумма $F = (\nabla E)E + [pH]/c$ и является силой П. д. с. В такой записи F не выражены явно физички различные ее составляющие. С учётом ур-ния Максвелла и соотношения $p = \hat{\alpha}E$, где $\hat{\alpha}$ — оператор полярности части-

цы, выражение для F приводится к следующему виду:

$$F = \nabla(E\hat{\alpha}E)/2 + (E\hat{\alpha} - \hat{\alpha}E) \times \dot{H}/2c + \frac{\partial}{\partial t} [EH]/c, \quad (*)$$

составляющие к-рого имеют разный смысл и значение. Первое слагаемое, определяемое плотностью энергии поля около частицы, такое же по форме, как и ponderomotorная сила в пост. электрич. поле; эта сила не выражает специфич. действия поля излучения. Среднее слагаемое — огубно излучательной природы, оно выражает давление света и описывает передачу импульса поля при поглощении и рассеянии волн. Величина постоянного во времени давления монохроматич. света с частотой ω выражается величиной $F_{\text{лс}} = -2\text{Im}\alpha_{\omega} \text{Re} \{ [E, H']/c \}$ и определяется плотностью потока энергии (P — плотность вектора) и ее диссипацией, характеризуемой мнимой частью полярности α_{ω} . Последнее слагаемое — сила Абрагама (см. Максвелла тензор напряжений) не имеет постоянной составляющей и осциллирует с удвоенной частотой света. В выражении (*) E_{ω} и H_{ω} — комплексные амплитуды электрич. и магн. полей. Отметим, что при действии света на изолиров. атомы в молекулы диссипация его энергии обусловлена радиатц. трением, т. е. рассеянием света.

В приведенных выше выражениях сила П. д. с. формально задается значением напряженности электрич. и магн. полей около частицы. Фактически эти поля не являются полями падающего света, а получаются при рассеянии света на частице и сильно отличаются от полей падающего света. Однако установлено, что ponderomotorное действие наименьшего рассеяния света слабо отличается от действия падающего на частицу света по той же причине, по к-рой самодействие в пост. электрич. поле не вызывает движения частиц.

В протяженных средах на каждый элемент объёма действует сила F , причём p для сред имеет смысл дипольного момента элемента объёма. В этом случае выражение для F определяет не только ponderomotorные, но и др. объёмные силы в среде, к-рые образуются потому, что p в среде имеет двойную зависимость от местоположения: через распределение поля и через распределение диэлектрич. характеристик среды, если эта среда неоднородна. Величина силы П. д. с., составляющей часть объёмной силы, наиб. просто определяется для слабопоглощающих оптиически изотропных сред в стационарных световых потоках:

$$f = -(E^2 \nabla \epsilon + H^2 \nabla \mu) / 8\pi + (\epsilon \mu - 1) \frac{\partial}{\partial t} [EH] / 4\pi c,$$

где ϵ — диэлектрическая и μ — магн. проницаемость. В этом выражении последнее слагаемое — сила Абрагама, а первое (гораздо большее второго, т. к. $\mu - 1 \ll 1$) имеет ненулевое значение на границе кусочно-однородных сред. Эта составляющая такая же по форме, как и ponderomotorная сила в пост. электрич. поле, но по существу иная, т. к. определяет эффект излучения — давление света. Различие между описаниями разных сил одной ф-лой кроется в различии возможных распределений плотности полей излучения и постоянного электрич. поля.

Исторически первоначально ponderomotorные силы объяснялись упругим натяжением силовых линий в среде, в связи с чем компоненты сил определялись через тензор натяжений Максвелла: $f_n = \partial T_{nj} / \partial z_j$. В результате интегрирования этого выражения по объёму тела компоненты силы П. д. с. могут быть представлены в виде потока импульса через поверхность тела: $F_n = \oint T_{nj} dS_j$. В общем случае для оптически изотропных сред с произвольной частотой и пространственной дисперсией диэлектрич. проницаемости, в частности для сильно поглощающих сред, представление силы П. д. с. через к-л. тензор энергии-импульса неизвестно.

П. д. с. вызывает как перемещение тел, так и их вращение вследствие сообщения светом момента импульса веществу. Так же, как и при сообщении импульса, вращающий момент сил создается как неспецифическим для излучения образом, так и благодаря свойственной излучению. Неспециф. эффект обусловлен анизотропией поляризуемости и несимметрией распределения поля. Специфич. эффект излучения вызывается изменением круговой поляризации поля при рассеянии и поглощении циркулярно поляризованного света (см. *Садовского эффект*).

Концепция П. д. с. обычно применяется в линейной оптике. При описании механич. действия света высокой интенсивности, сопровождающегося нелинейными эффектами, пондеромоторные силы вообще не выделяются, хотя иногда возможно обобщение понятия П. д. с. на случай зависимости восприимчивости атомов и молекул от интенсивности облучения (см. *Нелинейные восприимчивости*).

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электродинамики, 10 изд., М., 1989; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Зинкин А., Давление лазерного излучения, «УФН», 1973, т. 110, с. 101; Аскария Г. А., Движение частиц в поле лазера, там же, с. 115; Гьянзбург В. Л., Угаров В. А., Несколько замечаний о силах и тензоре энергии-импульса в макроскопической электродинамике, там же, 1978, т. 118, с. 175; С. Г. Прессельский.

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ в акустическом поле — совокупность сил, действующих на вещество тела, помещённое в звуковом поле. В П. с. вносят вклад переменное акустическое давление, пропорциональное амплитуде звука, и квадратичные эффекты — радиал. давление, силы Бьеркнеса (см. ниже), а также гидродинамич. силы, обусловленные движением среды в звуковой волне. П. с. проявляются в действии звуковой волны на чувствит. элементы приёмников звука, а УЗ-коагуляции, диспергировании, кавитации, в возникновении *акустических течений*, усталости материалов, подвергающихся длит. воздействию интенсивного акустич. излучения, во вступлении границ раздела двух сред.

Сила, действующая на элемент объёма ΔV и равная $f \Delta V$, где f — объёмная плотность П. с., определяется изменением импульса (см. *Импульс звуковой волны*) элемента объёма ΔV в единицу времени, равным импульсу, втекающему в объём через его поверхность. Если тензор плотности потока импульса — Π_{ik} , то i -я компонента силы, действующая на объём ΔV , определяется выражением

$$\int_{\Delta V} f_i dV = \oint \Pi_{ik} dS_k = \oint \Pi_{ik} n_k dS,$$

где dS — элемент поверхности, ограничивающий объём, а n_k — внешняя по отношению к объёму нормаль. Соответственно этому сила, действующая на элемент поверхности dS , равна потоку импульса через него и определяется выражением $\Pi_{ik} dS_k$. В частности, на поверхности единичной площади действует сила, i -я компонента к-рой $F_i = \Pi_{ik} n_k$. Тензор плотности потока импульса звуковой волны

$$\Pi_{ik} = -p\delta_{ik} - \rho v_i v_k + \sigma_{ik},$$

где p — акустическое давление, v_i — компонента колебательной скорости частицы, δ_{ik} — символ Кронекера ($\delta_{ik} = 1$ при $i = k$, $\delta_{ik} = 0$ при $i \neq k$), σ_{ik} — тензор звуков. напряжений, ρ — плотность среды. Если поверхность жёсткая, то скорость частиц среды, прилегающих к ней, обращается в нуль и сила, действующая на единицу её площади, равна $F_i = -p\delta_{ik} n_k + \sigma_{ik} n_k$.

Общ. вклад в силу при таких условиях даёт звуковое давление p , и именно эта величина воспринимается чувствит. элементами приёмников звука. Для монокр. волн звуков. волн p — гармонич. ф-ция времени, связывающаяся с частотой звука. В жидкостях при интенсивности звука $I \approx 1$ Вт/см², характерной для ря-

да практич. применений в УЗ-технологии, $p = 10^4$ Па. Такие силы могут превышать порог прочности жидкости и вызвать *кавитацию*. Средняя по времени П. с., обусловленная звуковым давлением в гармонич. звуковых полях, равна нулю.

Помимо этого в звуковых полях возникают постоянные во времени П. с. Они определяются квадратичными членами тензора плотности потока импульса, усреднёнными по периоду колебаний звука. Отличные от нуля эти члены по порядку величины равны плотности энергии звуковой волны: $F_p = E = \rho v^2$. Обычно эти силы можно рассматривать как результат действия радиал. давления, или *давления звукового излучения*. Их величина мала, напр. в воздухе $F_p \sim 10^{-7}$ Па при интенсивности звука 10^9 Вт/см², в воде $F_p \sim 10$ Па при интенсивности звука 1 Вт/см². Тем не менее они приводят к заметным эффектам, проявляющимся, напр., в появлении акустич. течений, во вступлении границ раздела двух сред и даже в возникновении фонтанич. жидкости.

П. с. значит. величины действуют не только на элементы среды, в к-рой возбуждено звуковое поле, но и на границах с ней поверхности, а также на тела, находящиеся в среде. Так, напр., на вешенное в акустич. поле тело, размеры к-рого много меньше длины звуковой волны λ , а плотность равна плотности окружающей среды, в звуковом поле действует сила, заставляющая его колебаться вместе с частицами среды. При отличии плотности тела ρ от плотности ρ окружающей среды возникает движение тела относительно среды, причём если $\rho_1 > \rho$ — то оно отстоит от частиц среды, а если $\rho_1 < \rho$ — то опережает их. Движение тела относительно среды вызывает дополнит. движением среды (рассеянную волну), а значит, и дополнит. силу реакции, действующую на тело. Напр., на жёсткую сферу радиуса a при $a \ll \lambda$ в поле плоской бегущей звуковой волны действует сила

$$F_p = 4\pi a^2 F (ka)^4 \frac{1 + \nu/(1 - \delta)^2}{(2 + \delta)^2},$$

где $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число звуковой волны, E — средняя по времени плотность энергии акустич. поля, $\delta = \rho/\rho_1$.

Если вблизи одного из тел в звуковом поле имеется другое, то влияние на первое тело рассеянной волны, исходящей от второго тела, приводит к появлению добавочной силы. Эта сила имеет характер вторичного радиал. давления и приводит к взаимодействию тел в звуковом поле. В частности, две сферы с радиусами a и b , пульсирующие в звуковом поле на расстоянии r друг от друга, притягиваются друг к другу с силой

$$F_b = 4\pi a^2 b^2 \frac{v_a v_b}{r^4} \cos \varphi,$$

где v_a, v_b — колебат. скорости поверхностей сфер, φ — сдвиг фаз их колебаний, ρ — плотности среды; F_b наз. силой Бьеркнеса. Между осциллирующими сферами возникают более слабые силы взаимодействия; для двух сфер, осциллирующих в звуковом поле под действием звука со скоростями v_a и v_b , центральная составляющая этой силы равна

$$F_b = \frac{3}{2} \rho \frac{(1 - \delta)^2}{\delta^2} \frac{a^2 b^2}{r^4} v_a' v_b' \cos \varphi (1 + 3 \cos 2\alpha)$$

(α — угол между направлением колебаний тел и линией, соединяющих их центры).

Наряду с силами акустич. происхождения, зависящими от сжимаемости среды, на тела, помещённые в звуковом поле, действуют также силы, вызванные движением тела относительно среды. Такие силы наз. гидродинамическими. К их числу относится сила сопротивления, к-рую испытывает тело, движущееся с пост. скоростью в вязкой жидкости. Для жёсткой сферы радиуса a , движущейся со скоростью v ,

эта сила выражается ф-лой Стокса: $F_c = \text{блвр}$, где ν — коэф. динамич. вязкости среды.

Др. примером гидродинамич. силы является сила Бернулли, притягивающая тела, движущиеся в жидкости или омываемые ею. Для случая двух жестких сфер с радиусами a и b , находящихся на расстоянии r друг от друга в потоке жидкости, движущейся со скоростью v , сила Бернулли равна

$$F_b = \frac{3}{2} \pi r \frac{\rho v^2}{r^3} v^3.$$

Эта сила действует, в частности, на находящиеся в звуковой поле жесткие частицы, малые по сравнению с λ . Заметим, что в случае возникновения акустич. течений и микропотоков при кавитации различие между гидродинамич. силами и усредненными по времени П. с. бывает часто условным.

П. с. используются в разнообразных приборах звуку, устройствах, измеряющих его интенсивность (радиометр, Рэлея диск). На действии П. с. основаны эффекты коагуляции, дегазации жидкостей и металлов, диспергирования твердых тел в жидкости, эмульгирования и т. п., применяемые в УЗ-технологии.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика сплошных сред, 2 изд., М., 1954; Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957, гл. 6; Лебедев П. Н., Собр. соч., М., 1963, с. 69; Кривильников В. А., Крылов В. В., Введение в физику акустики, М., 1984. Н. А. Назарович.

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ в электродинамике — силы, действующие на тела в электрич. и магн. полях. Термин «П. с.» введен во времена, когда наряду с весовыми телами признавалось существование невесомых субстанций (афир, электрич. жидкость и т. п.); в совр. лексиконе иногда говорят просто об эл.-магн. силах.

Плотность П. с. связана с тензором напряжений σ_{ik} (см. *Напряжение механическое*) соотношением

$$f_i = \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k},$$

где f_i — i -я компонента плотности П. с., x_k — пространственные координаты ($i, k = 1, 2, 3$). В электрич. поле П. с. действуют как на проводящие, так и на диэлектрич. тела. Для изотропной жидкой диэлектрич. среды

$$f = \frac{1}{8\pi} \nabla [E^2 \epsilon \left(\frac{\partial \epsilon}{\partial t} \right)] - \frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon + \rho E, \quad (1)$$

где ϵ — диэлектрич. проницаемость, ρ — плотность среды, ρ — плотность сторонних зарядов (здесь и далее используется гауссова система единиц). Последний член описывает силы, действующие на сторонние заряды в диэлектрике. Наб. простой вид плотность объемных П. с. имеет в газе, где ϵ пропорциональна T :

$$f = \frac{\epsilon - 1}{8\pi} \nabla E^2.$$

В случае металлов в электростатич. поле П. с. действуют только на их поверхность, создавая отрицательное давление, равное $E^2/8\pi$, где E — поле на поверхности проводника (ортогональное ей). В случае твердого диэлектрика ф-лы для П. с. имеют более сложный вид, поскольку в (1) необходимо добавить члены, связанные с изменением тензора диэлектрич. проницаемости под действием деформаций сдвига, не изменяющих плотность тела. Кроме того, в кристаллах ряда низкосимметрич. кристаллич. классов — *пьезоэлектриках* — возникает напряжения, пропорциональные не второй, а первой степени электрич. поля.

Объемные интегралы, определяющие полную силу F и момент сил K , действующие на тело в целом, можно свести к интегралам по поверхности S , охватывающей это тело:

$$F = \frac{e}{4\pi} \oint_S \left[E(nE) - \frac{1}{2} E^2 n \right] dS, \quad (2)$$

$$K = \frac{e}{4\pi} \oint_S \left[(rE)(nE) - \frac{1}{2} E^2 (rn) \right] dS,$$

где e — диэлектрич. проницаемость веш. (однородной) среды, r и n — радиус-вектор и веш. нормаль к элементу поверхности. Эти силы, в частности, приводят к притяжению диэлектрика в области с большими значениями E .

Аналогично случаю электрич. поля на тело с магнитной проницаемостью μ действует сила со стороны магн. поля с объемной плотностью

$$f = \frac{1}{8\pi} \nabla [H^2 \mu \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)] - \frac{H^2}{8\pi} \nabla \mu + \frac{\mu}{c} [jH]. \quad (3)$$

Первые два члена связаны с воздействием непосредственно на магнетик, последний член — с силами, действующими на токи проводимости и токи, связанные с перемещением сторонних зарядов. В случае $\mu \approx 1$ этот член оказывается основным и сила, действующая на проводник с током, равна

$$F = \frac{\mu}{c} \int [jH] dV. \quad (4)$$

Эта ф-ла применима как к жидким, так и к твердым проводникам. Если принять, что ток j протекает по линейному (т. е. тонкому) проводнику, в магн. поле H создается др. линейных проводниками с током, то из (4) следует *Ву — Саавра закон*. В общем случае ф-ла (4) определяет также внутренние силы, с к-рыми разл. участки проводника взаимодействуют друг на друга. Так, на катушку с током действуют П. с., сжимающие её вдоль осей и растягивающие в радиальном направлении, что, в частности, затрудняет получение сильных магн. полей из-за ограниченной механич. прочности катушки.

П. с. часто удобнее вычислять, используя закон сохранения энергии для системы тел с учётом полей. Под действием П. с. происходит деформация тел — *электрострикции* и *магнитострикции*, поэтому для вычисления равновесных состояний необходимо учитывать и силы упругости, возникающие при такой деформации.

В перем. эл.-магн. поле объемная плотность П. с. отличается от суммы выражений (1) и (2) дополнит. слагаемым $\{(e\mu - 1)/4\pi c\} \partial [E \cdot H] / \partial t$, называемым силой Абратова. Одной из разновидностей П. с. являются силы давления эл.-магн. воли (передача импульса и момента импульса телу при поглощении, отражении и преломлении эл.-магн. воли), в частности *Балезине света* и *Сабосского эффект*.

Лит.: Тамм И. Э., Основы теории электродинамики, 10 изд., М., 1989; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Сивухин Д. В., Общий курс физики, 2 изд., [т. 3] — Электродинамика, М., 1983, гл. 10.

ПОПЕРЕЧНАЯ ВОЛНА — волна, у к-рой характеризующая её векторная величина лежит в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны (для гармонич. волн — волновому вектору k). К П. в. относят, напр., волны в струнах или упругих мембранах, когда смещения частиц в них происходят строго перпендикулярно направлению распространения волны, а также плоские однородные эл.-магн. волны в изотропном диэлектрике или магнетике; в этом случае поперечные колебания совершают векторы электрич. и магн. полей.

П. в. обладает поляризацией, т. е. вектор её амплитуды опред. образом ориентирован в поперечной плоскости. В частности, различают линейную, круговую и эллиптич. поляризацию в зависимости от формы кривой, к-рую описывает конец вектора амплитуды (см. *Поляризация волн, Поляризация света*). Понятие П. в.

так же, как и продольной волны, до нек-рой степени условно и связано со способом её описания. «Поперечность» и «продольность» волны определяются тем, какие величины реально наблюдаются. Так, плоская эластич. волна может описываться продольным *Герца* вектором. В ряде случаев разделение волн на продольные и поперечные вообще теряет смысл. Так, в гармонич. волне на поверхности глубокой воды (см. *Волны на поверхности жидкости*) частицы среды совершают круговые движения в вертикал. плоскости, проходящей через волновой вектор k , т. е. колебания частиц имеют как продольную, так и поперечную составляющие.

ПОРОГ БОЛЕВОГО ОЩУЩЕНИЯ — см. *Боль*.
ПОРОГ ЗРИТЕЛЬНОГО ОЩУЩЕНИЯ — минимальная интенсивность света, вызывающая зрительное ощущение. Величина П. з. о. зависит от адаптации глаза к световому воздействию и от угл. размеров наблюдаемого объекта. При ночном зрении, когда яркость объектов не превышает 10^{-3} кд/м², работает только палочковый зрительный аппарат (см. *Зрение*), чувствительность глаза очень велика и человек способен видеть объекты 10⁻⁶ величина, что соответствует освещенности зрачка глаза 9·10⁻⁹ лк. В условиях зрительного темновой адаптации для появления зрительного ощущения достаточно 3—4 фотона (сине-фиолетовой участка спектра). Мин. порог составляет 9·10⁻¹⁹ лм (8·10⁻⁸ кд/м²). Это порог акроматии. Ночного зрения, когда все окрашенные предметы воспринимаются только белыми, серыми или черными. Число различимых по яркости акроматич. полей объекта составляет от 10 до 100 в зависимости от размеров объекта и четкости границ объектов и фоном.

Колбочковый зрительный аппарат, обеспечивающий цветное зрение, начинает работать с уровня яркости $\sim 10^{-4}$ кд/м², с к-рого начинается т. н. сумеречное зрение, когда работают и палочки, и колбочки. При яркости ≥ 125 кд/м² палочки теряют чувствительность и только колбочки несут информацию о поле зрения. Эта область дневного зрения, к-рая сверху ограничивается сленнейшей яркостью на уровне $\sim 10^{-2}$ кд/м². П. з. о. дневного (колбочкового) зрения зависит от длины волны света (см. *Цветовая адаптация*).

Лит.: В а р з и я И. В. Проблемы порогов чувствительности и психофизические методы. М., 1978. Н. А. Валов.

ПОРОГ СЛЫШИМОСТИ — см. *Пороги слуха*.

ПОРОГИ СЛУХА — значения физ. характеристик звука, соответствующие возникновению слухового ощущения или изменению качества этого ощущения. Уровень интенсивности звука, соответствующий возникновению слухового ощущения в условиях типичной, наз. **абсолютный П. с.** или **порогом слышимости**. У молодых людей нижняя граница абс. П. с. наблюдается в диапазоне частот 1,0—4,0 кГц и составляет по давлению сотые доли мПа. Величина 2·10⁻⁵ Па условно принята в качестве точки отсчета при введении шкалы уровней звукового давления, измераемой в дБ. Зависимость абс. П. с. чистых тонов от частоты наз. **аудиограммой**. Тем же термином обозначают в частотной зависимости отклонений абс. П. с. конкретного человека от нормативных П. с., принятых для данной частоты международным стандартом. Аудиограммы используют при диагностике слуховых нарушений. Абс. П. с. растут с уменьшением длительности тонов; для сигналов короче 0,3 с десятикратное уменьшение длительности приводит к повышению абс. П. с. примерно на 10 дБ. Ограничение области слышимости человека со стороны высоких уровней интенсивности определяется существованием т. н. **б. о. г. в. х. Ч. порога** (наз. также порогами ощущения покалывания, шекотания, ослепания). Болевые П. с. мало зависят от частоты звука. Уровень звукового давления болевого П. с. составляет, как правило, 120—150 дБ.

Наряду с абсолютными существуют разностные П. с., соответствующие разности параметров сигнала, приводя-

щей к изменению качества ощущения. Частное от деления разностных П. с. на ср. значение изменяемого параметра наз. **дифференциальными П. с.** и обычно выражают в %. Согласно закону Вебера, дифференциальный П. с. должен слабо зависеть от ср. значения изменяемого параметра. Этот закон выполняется, однако, только в особых случаях, напр. для дифференциального П. с. по интенсивности широкополосных шумов в диапазоне уровней выше 30 дБ над абс. П. с. этого звука. Дифференциальный П. с. по интенсивности для тонов уменьшается с повышением уровня от 30—50% вблизи порога до 3—5% на уровнях ок. 90 дБ. Дифференциальный П. с. по частоте с ростом частоты уменьшается от 1—2% на частоте 0,1 кГц до 0,1—0,2% на частоте 2,0 кГц, но при дальнейшем росте частоты они вновь возрастают, достигая 2—3% на частоте 10 кГц. Дифференциальный П. с. могут быть определены и для длительности сигнала. Для чистых тонов длительностью короче 0,1 с они составляют десятки %, на высоких уровнях уменьшаются до 5—8%.

Для определения П. с. обычно применяют метод вынужденного выбора, при к-ром испытуемый указывает, в каком из заданных интервалов времени сигнал имеется или отличается по своему звучанию от эталонного. При использовании более традиционного, порогового метода, когда испытуемый должен указать, слышит он сигнал или нет, большую роль играют предвостройка испытуемого, степень его тренированности, уверенности в себе и т. д. Частично от такой субъективности можно избавиться, учитывая не только число правильно ознанных сигналов, но и число ложных тревог и пропусков сигнала. Для измерения П. с. можно также использовать методы объективной аудиометрии, когда возникновение слухового ощущения определяют по появлению электрич. ответов в центр. нервной системе. Наиб. распространение получают регистрации т. н. коротколатентных потенциалов ствола мозга. Объективная аудиометрия особенно важна для изучения слуха детей и лиц с тяжелыми слуховыми нарушениями.

П. с. животных можно определять как методами объективной аудиометрии, так и при изучении их поведения. Абс. П. с. в области высоких звуковых и V3-частот у многих животных существенно ниже, чем у человека. Так, кошка в частотном диапазоне 3—8 кГц слышит звуки с давлением ок. 10⁻⁸ Па, что, по-видимому, объясняется усилением сигнала за счёт резонанса ушной раковины. Кроме того, большинство млекопитающих обладают высокой чувствительностью в частотном диапазоне 30—60 кГц, летучие мыши и зубчатые киты воспринимают и анализируют сигналы частотой 150—200 кГц. У наземных позвоночных (амфибии, рептилии, рыбы) V4-граница слуха снижена до 1—5 кГц, гл. обр. вследствие ограничений, накладываемых механич. характеристиками звуковоспринимающих структур. Дифференциальный П. с. у животных ниже только для тех звуков, анализ к-рых осуществлен для выживания в естестве. Условия существования вида (коммуникац. сигналы, сигналы, издаваемые хищником или предполагаемой жертвой).

П. с. одного сигнала (тестового) может определяться и в присутствии др. звука — маскира. Такие пороги маскировки широко используются для изучения частотной селективности слуха, его помехоустойчивости и в ряде др. случаев (см. *Маскировка звука*). Как абсолютные, так и дифференциальные П. с. могут меняться после продолжит. воздействия громких звуков.

Лит.: Физиология сенсорных систем, Л., 1976.

Н. Г. Бибиков,

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР химического элемента — то же, что *атомный номер*.

ПОРЯДОК ИНТЕРФЕРЕНЦИИ — величина, равная разности хода интерферирующих лучей, выраженной в длинах световых волн. Если интерферирующие лучи отражаются от к-л. поверхности и при этом проис-

ходит изменение фазы, то в П. и. входит алгебраич. сумма всех скачков фаз, выраженная в радианной мере (см. *Отражение света*). При совпадении нач. фаз источников целые значения П. и. соответствуют максимумам, а полуполные — минимумам интерференц. картин. В реальных устройствах, предназначенных для наблюдения интерференц. П. и. меняются от единиц (*Френеля зеркала*, *Ньютона кольца*, *двухлучевые интерферометры*) до 10^8 и более (*интерферометр Фабри — Перо*). Чем выше П. и., тем более монохроматичным должен быть свет для наблюдения интерференц. картин.

См. также ст. *Интерференция света* и лит. при ней.

ПОСЛЕДСТВИЕ МАГНИТНОЕ — см. *Магнитная вязкость*.

ПОСЛЕДСТВИЕ УПРУГОЕ — явление релаксации, состоящее в изменении с течением времени деформиров. состояния твёрдого тела при неизменном напряжённом состоянии. П. у. характеризуется однозначностью условий равновесия (полная восстанавливаемость) между напряжением и деформацией, равновесное значение к-рой достигается по истечении достаточного времени (от микросекунд и меньше до очень больших промежутков времени). Продолжительность изменения — врем. релаксации — зависит от способа и темп-ры деформации, а также предистории и свойства твёрдого тела.

Различают прямое П. у. и обратное. Если к телу приложить пост. напряжение, то мгновенно (со скоростью звука) возникнет упругая деформация ϵ_y (рис.), к-рая в дальнейшем будет увеличиваться во времени t , асимптотически приближаясь к равновесному значению ϵ_p . Приrost дополнит. упругой деформации $\delta\epsilon = \epsilon_p - \epsilon_y$ наз. прямым П. у., в отличие от обратного П. у., где после устранения напряжения мгновенно снимается упругая деформация ϵ_y , а дополнит. $\delta\epsilon$ асимптотически исчезает во времени. Дополнит. упругая деформация составляет малую часть полной равновесной упругой деформации. При знакопеременном нагружении П. у. проявляется в *гистерезисе упругого*. В отличие от *получности материала*, прямое П. у. полностью обратимо, что нашло отражение в термине *обратимая полнучность*, встречающемся в лит-ре для обозначения прямого П. у.

П. у. связано с наличием в материале точечных и линейных дефектов, их движением, взаимодействием и аннигиляцией.

Лит.: Н о в и к А. Б., Б е р р и Е., Релаксационные явления в кристаллах пер. с англ., М., 1975. *Ю. В. Пылаков.*

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ МЕТОД — то же, что *итераций метод*.

ПОСЛЕДСТВИЕ — люминесценция, наблюдающаяся после прекращения вызвавшего её внеш. воздействия (света, рентг. излучения, потока электронов и т. д.). П. — характерный признак люминесценции. В нек-рых случаях может продолжаться до неск. часов.

ПОСТОЯННАЯ ВЕРДЕ — см. *Верде постоянная*.

ПОСТОЯННАЯ ВРАЩЕНИЯ — см. *Вращение плоскости поляризации света*.

ПОСТОЯННАЯ РАСПАДА — константа, характеризующая радиоактивный распад:

$$\lambda = 1/\tau,$$

где τ — время жизни радиоактивного ядра. П. р. связана с *периодом полураспада* $T_{1/2}$ соотношением

$$\lambda = 0,693/T_{1/2}.$$

Лит. см. при ст. *Радиоактивность*.

ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ — см. *Магнит постоянный*.
ПОСТОЯННЫЙ ТОК — *электрический ток*, плотность к-рого j не зависит от времени. Микроскопич. природа П. т. состоит в направленном чередовании дискретных заряд. частиц, но макроскопически он может рассматриваться как непрерывный процесс, аналогичный течению жидкости или газа. Чаще всего П. т. обусловлен движением зарядов в токопроводящих средах. Стационарный поток заряд. частиц в пустоте также представляет собой П. т.

Закон сохранения элктрич. заряда диктует для П. т. условие $\operatorname{div} j = 0$. Это практически всегда (исключая умозр. примеры экзотич. топологий) ведёт к замкнутости линий плотности П. т. (часто их наз. просто линиями тока). Тогда замкнутость оказывается и цель в целом. В силу того же закона каждое разветвление цепи подчинено *Кирхгофа правилам*. В обычных условиях вектор j пропорционален напряжённости элктрич. поля E , а сила тока I в конечном проводнике — приложенному напряжению U (*Ома закон*). При сильных полях эта линейная зависимость может нарушаться, соответственно говорят о *нелинейных явлениях* в элктрич. цепях.

Протекание П. т. сопровождается выделением джоулевой тепла в проводнике (*джоулевы потери*). Тепловая мощность тока Q определяется *Джоуля — Ленца законом*, $Q = R I^2$ (R — сопротивление проводника). Для компенсации этих энергетич. потерь в цепь П. т. включается источник *электродвижущей силы* (эдс). Компенсация достигается за счёт механич., тепловой энергии (генераторы тока, *магнитогидродинамические генераторы*), энергии хим. реакций (хим. источники тока), тепловой диффузии носителей тока (см. *Термоэдс*), фотоэффекта (*солнечные батареи*) и т. д. Только при наличии сверхпроводимости ($R = 0$) П. т. могут циркулировать по цепям без указанной компенсации.

Согласно *Максвелла уравнениям*, проводник с П. т. создаёт вокруг себя магн. поле. В частном случае протяжённых линейных проводников это поле вычисляется по *Био — Саавара закону*. Магн. поле тока можно значительно сконцентрировать и усилить, если свить линейный проводник в спираль (*соленоид*). Замкнутый на себя тороидальный соленоид с П. т. не создаёт внеш. магн. поля, но обладает т. н. *аналепным моментом* (см. *Аналеп*).

П. т. широко применяется для электролиза в хим. пром-сти и металлургии, на транспорте (тяговые электродвигатели). Источники П. т. используются в прецизионных измерит. приборах, для питания малошумящей электронной аппаратуры, бытовых радиоприёмников и т. д. В энергетике линии электропередач на П. т. имеют ряд преимуществ перед традиционными, поскольку менее подвержены разл. рода потерям. Из-за неудобства трансформации напряжений П. т. они пока не получили достаточно широкого распространения, хотя представляются перспективными.

Лит.: С в я х у х и н Д. В. *Общий курс физики*. 2 изд., [т. 3] — Электричество, М., 1983; А х и з е р А. И., *Общая физика*. Электрические и магнитные явления, К., 1981.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ — движение твёрдого тела, при к-ром прямая, соединяющая две любые точки тела, перемещается параллельно своему нач. направлению. При П. д. все точки тела описывают одинаковые (при наложении совпадающей траектории) и имеют в каждый момент времени одинаковые по модулю и направлению скорости и ускорения. Поэтому изучение П. д. твёрдого тела сводится к задаче кинематики точки (см. *Кинематика*).

ПОТЕНЦИАЛ (потенциальная функция) (от лат. *potentia* — сила) — характеристика векторных полей, к к-рым относятся многие силовые поля (эл.-магн., гравитационное), а также поле скоростей в жидкости и др. Если П. векторного поля $X(r)$ есть скалярная ф-ция $\phi(r)$, $X = \operatorname{grad} \phi$, то поле X наз. *потенциальным* (иногда П. ваз. ф-цию $U = -\phi$). П. ϕ определён с точ-

ностью до пост. величины. Для потенц. поля X справедливы условие $[\nabla X] = 0$, и обратно, если для нек-рого поля X всюду $[\nabla X] = 0$, то поле X — потенциальное, для него существует П.

Если нек-рое поле U соленоидально, т. е. $\nabla U = 0$, то для этого поля можно ввести векторный потенциал A , такой, что $U = [\nabla A]$, при этом A определен с точностью до градиента произвольной ф-ции (градиентная инвариантность). В общем случае любое векторное поле представляется суммой потенциального и соленоидального полей.

В классич. и квантовой физике измеряемыми на опыте являются силовые характеристики полей — их напряженности. На первый взгляд представляется, что сами по себе потенциалы полей не несут физ. смысл, а их введение в теорию — не более чем удобный техн. приём. Оказывается, однако, что в квантовой механике возникают эффекты (квантование магнитного потока, Ааронова — Бома эффект, Джозефсона эффект, эффект Казимира), в к-рых физ. природа П. проявляется непосредственно. Все эти эффекты имеют наглядную геом. интерпретацию. Векторный потенциал представляет собой связность в расслоении, базой к-рого служит соответствующее пространство (напр., пространство Минковского M_4). В квантовой теории поля ось. объект исследования — квантовые поля — являются аналитами классич. П., т. к. набор потенциальных ф-ций — мин. набор независимых динамич. переменных, полностью описывающий систему. Напр., в квантовой электродинамике такими переменными будут квантовые поля (потенциалы) $A_\mu(r, t)$, где 4-компонентный вектор A_μ задается потенциалами ϕ и A : $A_\mu = (\phi, A_x, A_y, A_z)$.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Славнов А. А., Фаддеев Л. Д., Введение в квантовую теорию калибровочных полей, 2 изд., М., 1986.

ПОТЕНЦИАЛ ВУДСА — САРКСОНА — используемый в ядерных моделях потенциал вида

$$V(r) = \frac{V_0}{1 + \exp[(r-R)/a]}$$

где r — расстояние до центра ядра; V_0 , R , a — параметры, характеризующие глубину, радиус и размытие потенциала (см. Оболочечная модель ядра).

ПОТЕНЦИАЛ ЗАЖИГАНИЯ — см. Зажигания потенциал.

ПОТЕНЦИАЛЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ — функции определённого набора термодинамич. параметров, позволяющие найти все термодинамич. характеристики системы как функции этих параметров. Все П. т. связаны между собой: по любому на них с помощью дифференцирования по его параметрам можно найти все остальные потенциалы.

Метод П. т. разработан Дж. У. Гиббсом (J. W. Gibbs) в 1874 и является основой всей термодинамики, включая теорию многокомпонентных, многофазных и гетерогенных систем, а также термодинамич. теорию фазовых переходов. Существование П. т. — следствие 1-го и 2-го начал термодинамики. Статистич. физика позволяет вычислять П. т. исходя из представления о строении вещества как системы из большого числа взаимодействующих частей.

Внутренняя энергия $U(S, V, N)$ является П. т. в том случае, когда состояние системы характеризуется *интропией* S , объёмом V и числом частиц N , что характерно для однокомпонентных изотропных жидкостей и газов. U наз. также *изохорно-адиабатич. потенциалом*. Полный дифференциал U равен:

$$dU = TdS - pdV + \mu dN. \quad (1)$$

Здесь независимыми переменными являются три экстенсивные (пропорциональные V) величины S , V , N , а зависимыми — сопряжённые им интенсивные (конечные

в термодинамич. пределе $V \rightarrow \infty$) величины — темп-ра T , давление p и *химический потенциал* μ . Из условия, что U есть полный дифференциал, следует, что зависящие переменные T , p , μ должны быть частными производными от U :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, N}, \quad -p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S, N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S, V}. \quad (2)$$

Второй производной U по объёму даёт адиабатный коэф. упругости:

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_{S, N} = - \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{S, N}.$$

Теплоёмкость при пост. объёме равна

$$C_V = (\partial U / \partial T)_{V, N}.$$

Однако это не единственно возможный выбор независимых переменных, определяющих П. т. Их можно выбрать четырьмя разл. способами, когда независимыми являются одна термическая и две механ. величины: S, V, N ; S, p, N ; T, V, N ; T, p, N . Для того чтобы в полном дифференциале типа (1) заменить одну из независимых переменных ей сопряжённой, надо совершить *Лежандра преобразование*, т. е. вычесть произведение двух сопряжённых переменных.

Т. о. может быть получена анталия $H(S, p, N)$ (тепловая функция Гиббса), теплоемкость при пост. давлении, энтропия, энтропийный потенциал при независимых переменных S, p, N :

$$H(S, p, N) = U + pN, \quad (3)$$

откуда следует, что

$$dH = TdS - Vdp + \mu dN, \quad (4)$$

где

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p, N}; \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S, N}; \quad \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S, p}. \quad (5)$$

Знание H позволяет найти теплоёмкость при пост. давлении $C_p = (\partial H / \partial T)_{p, N}$.

Свободная энергия $F(T, V, N)$ (энергия Гельмгольца, телосодержание, изобарно-пзотермич. потенциал в переменных T, V, N) может быть получена с помощью преобразования Лежандра от переменных S, V, N к T, V, N :

$$F(T, V, N) = U - TS, \quad (6)$$

откуда

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN, \quad (7)$$

где

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V, N}; \quad p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T, N}; \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T, V}. \quad (8)$$

Вторые производные F по V и T дают теплоёмкость при пост. объёме $C_V = -T(\partial^2 F / \partial T^2)$, изотермич. коэф. давления

$$\gamma_T = - \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T, N} = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_{T, N}$$

и изохорный коэф. давления

$$\gamma_V = - \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V, N} = - \frac{1}{p} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T}\right)_{T}.$$

Последнее соотношение основано на независимости второй смешанной производной от П. т. от порядка дифференцирования. Этим же методом можно найти разность между C_p и C_V :

$$C_p - C_V = -T^2 \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 / \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

и соотношения между адиабатич. и изотермич. коэф. сжатия:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{C_p}{C_v}\right) \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T.$$

Энергия Гиббса $G(T, p, N)$ (изобарно-изотермический потенциал в переменных T, p, N) связана преобразованием Лежандра с П. т. U, H, F :

$$G(T, p, N) = U - TS + pV = H - TS = F + pV, \quad (9)$$

откуда

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dN, \quad (10)$$

где

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N}; \quad U = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N}; \quad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} = \frac{G}{N}. \quad (11)$$

Пропорциональность G числу частиц делает его очень удобным для приложений, особенно в теории фазовых переходов. Вторые производные G дают теплоёмкость при пост. давлении

$$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{p,N} = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_{p,N}$$

и изотермич. коэф. сжатия

$$\beta_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} = -\left(\frac{\partial^2 G}{\partial p^2}\right)_{T,N} / \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N}.$$

Из ур-ний (3), (5), (6), (8) следует, что П. т. U, H, F, G связаны уравнениями Гиббса — Гельмгольца:

$$U = H - p \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,N} = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad (12)$$

$$G = F - V \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = H - S \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,N}.$$

к-рые применяются для построения разл. П. т. по эксп-р-мент. данным о термич. и калорич. ур-ниях состояния. Необходимые для этого граничные условия даёт предельный переход к идеальному газу и *Нернста теорема*, к-рая устанавливает, что $S = 0$ в пределе $T \rightarrow 0$, и поэтому $U = F$ и $G = H$.

Для незамкнутых систем, для к-рых N не фиксировано, удобно выбрать П. т. в переменных T, V, μ , к-рый не получил специального названия и обычно обозначается $\Omega(T, V, \mu)$:

$$\Omega(T, V, \mu) = G - pV - \mu N = -pV. \quad (13)$$

Его полный дифференциал

$$d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu, \quad (14)$$

где

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu}; \quad p = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu}; \quad \mu = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial N}\right)_{T,V}. \quad (15)$$

Все П. т. связаны с различными Гиббса распределениями. П. т. $\Omega(T, V, \mu)$ связан с большим канонич. распределением Гиббса соотношением

$$\Omega = -kT \ln Z(T, V, \mu), \quad (16)$$

где $Z(T, V, \mu)$ — статистический интеграл по фазовым переменным и сумма по N в случае классич. механики или статистическая сумма по квантовым состояниям. П. т. $F(T, V, N)$ связан с канонич. ансамблем Гиббса:

$$F = -kT \ln Z(T, V, N), \quad (17)$$

где $Z(T, V, N)$ — статистич. интеграл в классич. случае и статистич. сумма в квантовом. П. т. H связан с изобарно-изотермич. ансамблем Гиббса, к-рый был предложен С. А. Богуславским (1922). П. т. U связан с микроканонич. распределением Гиббса через энтропию:

$$S(U, V, N) = k \ln W(U, V, N), \quad (18)$$

где $W(U, V, N)$ — статистич. вес, к-рый является нормировочным множителем для микроканонич. распределения Гиббса. Полный дифференциал энтропии равен

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN, \quad (19)$$

что эквивалентно ур-нию (1).

Статистич. интегралы или статистич. суммы в принципе можно вычислить исходя из функции Гамильтона в классич. случае или оператора Гамильтона в квантовом случае для системы из большого числа взаимодействующих частиц и т. о. вычислить П. т. методами статистич. механики.

Кроме перечисленных П. т. применяются и другие, напр. функции Массье — $F(T, V, N)/T$, функции Планка — $G(T, p, N)/T$. В общем случае, когда система с заданной энтропией описывается термодинамич. параметрами a_1, \dots, a_n и сопряжёнными им термодинамич. силами $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$.

$$U = U(S, a_1, \dots, a_n),$$

$$dU = T dS - \sum_{k=1}^n \mathcal{F}_k da_k + \mu dN, \quad (20)$$

и аналогично для систем с фиксиров. энергией.

Для поляризуемых сред П. т. зависит от векторов электрич. и магн. индукции D и H . Метод П. т. позволяет найти тензоры электрич. и магн. проницаемостей. В изотропном случае диэлектрич. проницаемость ϵ определяется из ур-ний

$$\frac{1}{\epsilon(T, V)} = -4\pi \frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial D^2}; \quad \frac{1}{\epsilon(T, p)} = -4\pi \frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial D^2}; \quad \frac{1}{\epsilon(S, V)} = -4\pi \frac{\partial^2 U}{\partial D^2}.$$

Особенно эффективно применение метода П. т. в том случае, когда между параметрами существуют связи, напр. для изучения условий термодинамич. равновесия гетерогенной системы, состоящей из соприкасающихся фаз и разл. компонент. В этом случае, если можно пренебречь внеш. силами и поверхностными явлениями, ср. энергия каждой фазы есть $U_k(S_k, V_k, N_k)$, где N_k^i — число частиц компоненты i в фазе k . Следовательно, для каждой из фаз

$$dU_k = T dS_k - p dV_k + \sum_i \mu_k^i dN_k^i \quad (21)$$

(μ_k^i — хим. потенциал компоненты i в фазе k). П. т. U минимален при условии, что полное число частиц каждой компоненты, полная энтропия и объём каждой фазы остаются постоянными.

Метод П. т. позволяет исследовать устойчивость термодинамич. равновесия системы относительно малых вариаций её термодинамич. параметров. Равновесие характеризуется макс. значением энтропии или минимумом её П. т. (внутр. энергии, энтальпии, свободной энергии, энергии Гиббса), соответствующих независимым в условиях опыта термодинамич. переменным.

Так, при независимых S, V, N для равновесия необходимо, чтобы была минимальна внутр. энергия, т. е. $\delta U = 0$ при малых вариациях переменных и при по-

стоястве S, V, N . Отсюда в качестве необходимого условия равновесия получаются постоянство давления и темп-ры всех фаз и равенство хим. потенциалов сосуществующих фаз. Однако для термодинамич. устойчивости этого недостаточно. Из условия минимальности П. т. следует положительность второй вариации: $\delta^2 U > 0$. Это вводит к условиям термодинамич. устойчивости, напр. к убыванию давления с ростом объёма и положительности теплоты при пост. объёме. Метод П. т. позволяет установить для многофазных и многокомпонентных систем Гиббса правило фаз, согласно к-рому число фаз, сосуществующих в равновесии, не превосходит числа независимых компонентов более чем на два. Это правило следует из того, что число независимых параметров не может превосходить числа ур-ний для их определения при равновесии фаз.

Для построения термодинамич. теории, к-рая учитывала бы и поверхностные явления, в вариациях П. т. следует учесть члены, пропорциональные вариации поверхности соприкасающихся фаз. Эти члены пропорциональны *поверхностному натяжению* σ , к-рое имеет смысл вариации производной любого из П. т. по поверхности.

Метод П. т. применим также и к непрерывным пространственно неоднородным средам. В этом случае П. т. являются функционалами от плотностей термодинамич. переменных, а термодинамич. равенства принимают вид ур-ний в функциональных производных.

Лит.: Ваальс И. Д. ван дер. Коэнстамм Ф., Курс термодинам. ч. 1. Общая термодинам. пер. с нем., М., 1936; Коэнстамм Ф. А., Химическая термодинам. пер. с нем., М., 1971; Гиббс Дж. В., Термодинам. Статистическая механика, пер. с англ., М., 1982; Новиков И. И., Термодинам. М., 1984.

ПОТЕНЦИАЛЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ — в электродинамике функции, через к-рые выражаются векторы, характеризующие эл.-магн. поле. Наиб. часто используются *векторный потенциал* A и *скалярный потенциал* φ ; через них может быть представлено решение двух однородных ур-ний Максвелла $\Delta B = 0$, $[\Delta E] = -(1/c) \partial B / \partial t$, не содержащих источников поля в явном виде:

$$B = [\Delta A], \quad E = -\frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t} - \Delta \varphi$$

(использована гауссова система единиц). В среде, характеризующейся однородными *электропроводностью* σ , *диэлектрической проницаемостью* ϵ и *магнитной проницаемостью* μ , ур-ния для П. з. п. имеют вид

$$\Delta A - \frac{\mu}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} - \frac{4\pi\sigma\mu}{c} \frac{\partial A}{\partial t} = -\Delta \left(\Delta A + \frac{4\pi\sigma\mu}{c} \varphi + \frac{\epsilon\mu}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\frac{4\pi j}{c},$$

$$\Delta \varphi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \Delta A = -\frac{4\pi}{\epsilon} \rho,$$

где j и ρ — объёмные плотности электр. токов и зарядов. Неоднозначность введения потенциалов для одних и тех же эл.-магн. полей позволяет накладывать на П. з. п. доп. условия, наз. условиями калибровки (см. *Градиентная инвариантность*); это даёт возможность видоизменить (иногда упрощать) ур-ния для П. з. п.

Часто в задачах об излучении и распространении эл.-магн. волн в непоглощающих средах ($\sigma = 0$) используется потенциал Герца (см. *Герца вектор*) Ω , через к-рый выражаются векторный и скалярный потенциалы:

$$A = \frac{\epsilon\mu}{c} \frac{\partial \Omega}{\partial t}, \quad \varphi = -\Delta \Omega;$$

звёздные т. о., они автоматически удовлетворяют условию калибровки Лоренца. Потенциал Герца удовлетворяет волновому ур-нию с электр. поляризацией

P (плотностью электр. дипольного момента) в качестве источника в правой части:

$$\Delta \Omega - \frac{\epsilon\mu}{c^2} \frac{\partial^2 \Omega}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} P.$$

Пользуясь принципом двойственности, для полей, создаваемых источниками магн. типа ($r^{(m)}$, $\rho^{(m)}$, см. *Максвелла уравнения*), можно ввести сопряжённые обычным П. з. п. магнитные П. з. п. $A^{(m)}$, $\varphi^{(m)}$, $\Omega^{(m)}$.

В задачах статки П. з. п. A и φ ($A^{(m)}$ и $\varphi^{(m)}$) обычно используются независимо друг от друга.

Лит. см. при ст. *Максвелла уравнения*.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (поверхность потенциальной энергии) молекул — зависимость внутренней (потенциальной) энергии молекулы от координат её ядер или др. координат, описывающих колебания атомов в молекуле (нормальных координат, внутр. колеб. координат типа растяжения связей и деформации валентных углов). При решении *Шрёдингера уравнения* для молекулы в *адиабатическом приближении* П. п. получается как зависимость энергии данного электронного состояния от координат ядер. В общем случае многоатомной молекулы П. п. (3N — 6)-мерная (N — число атомов в молекуле, для линейных молекул П. п. (3N — 5)-мерная. Для двухатомной молекулы П. п. одномерная и наз. просто потенциальной ф-цией. В адиабатич. приближении П. п. не зависит от изотопного состава молекулы.

Существуют два способа определения П. п. Первый основан на применении методов *квантовой химии*. Например, методы квантовой химии, учитывающие электронную корреляцию, способны качественно правильно определять форму П. п. (положение абс. и относит. минимумов, седловых точек и максимумов) и давать оценки барьеров на пути внутримолекулярных перегруппировок. Методы квантовой химии совершенствуются, и её возможности возрастают, по в наст. время (1990-е гг.) более точным методом определения параметров П. п. является решение обратной спектральной задачи. Он основан на применении эксперим. данных, найденных по колеб.-вращат. спектрам в квантовой механике расчётах. При этом выражение для потенц. энергии (потенциала V) разлагают в многомерный ряд Тейлора по степеням координат ядер *вблизи равновесной конфигурации* молекулы и ограничиваются нек. первыми членами ряда в зависимости от задачи и наличия необходимого кол-ва эксперим. данных. В безразмерных нормальных координатах q_k , к-рые связаны с обычными нормальными координатами $Q = (\hbar c \omega_k / h^2)^{-1/2} q_k$, этот ряд имеет вид

$$V = \frac{1}{2} \sum_k \omega_k^2 q_k^2 + \frac{1}{3!} \sum_{i,j,k} K_{ijk} q_i q_j q_k + \frac{1}{4!} \sum_{i,j,k,l} K_{ijkl} q_i q_j q_k q_l + \dots, \quad (*)$$

где ω_k — частоты гармонич. колебаний, K_{ijk} — кубические, K_{ijkl} — квадратичные коэф. агармоничности [все коэф. в (*) имеют одинаковую размерность (обычно см^{-1})]; ω_k определяются экспериментально из частот колеб. переходов, а от коэф. агармоничности зависит мн. спектроскопич. константы, также определяемые из эксперимента. Константы, характеризующие зависимость вращат. постоянных от колеб. состояния, константы, описывающие зависимость корриктисовых постоянных от вращат. состояния, и константы секстичного центробежного искажения линейно зависят от K_{ijk} и используются для их определения. Для определения K_{ijkl} служат измеряемые величины постоянных агармоничности, описывающих зависимость квадратичных центробежных констант от колеб. состояния, и др. константы колеб.-вращат. взаимодействий высоких порядков.

Измеряемых констант для одной молекулы обычно значительно меньше, чем коэф. ряда (*). Поэтому для определения всех коэф. используются спектроскопич. константы изотопич. разновидностей данной молекулы. Для этого в (*) переходит к внутр. наименьшим колеб. координатам, не зависящим от масс атомов, в к-рых коэф. ряда (*) также не зависят от масс атомов.

Для координат, по к-рым осуществляется туннелирование между разл. равновесными конфигурациями, ряд (*) неприменим; он неприменим также для колебания с большой амплитудой влияния равновесной конфигурации. В этих случаях используются модельные г. п. При изучении хим. реакций и задач рассеяния применяются П. и. основного и возбуждённых состояний.

Лит. см. при ст. Молекулярная, Молекулярные спектры.

М. Р. Ахиев.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ — часть энергии механич. системы, находящейся в нек-ром силовом поле, зависящая от положения точек (частиц) системы в этом поле, т. е. от их координат x_k, y_k, z_k или от обобщённых координат системы q_i . Численно П. э. системы в данном её положении равна той работе, к-рую произведут действующие на систему силы поля при перемещении системы из этого положения в то, где П. э. условно принимается равной нулю (нулевое положение). Из определения следует, что понятие П. э. имеет место только для систем, находящихся в потенциальном силовом поле, в к-ром работа действующих на систему сил поля зависит только от начального и конечного положений системы и не зависит от закона движения точек системы, в частности от вида их траекторий. Напр., для механич. системы, находящейся в однородном поле тяжести, если s — ось z направлена вертикально вверх, П. э. $\Pi = mgsz$, где m — масса системы, g — ускорение силы тяжести, z_0 — координата центра масс (нулевое положение $z_0 = 0$); для двух частиц с массами m_1 и m_2 , притягивающихся друг к другу по всемирного тяготения закону, $\Pi = -Gm_1m_2/r$, где G — гравитационная постоянная, $r = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$ — расстояние между частицами (нулевое положение $r = \infty$). Аналогично определяется П. э. двух точечных зарядов e_1 и e_2 .

С силовую ф-цию $U(\dots, x_k, y_k, z_k, \dots)$ П. э. связана соотношением

$$\Pi(\dots, x_k, y_k, z_k, \dots) = -U(\dots, x_k, y_k, z_k, \dots).$$

Следовательно, П. э. и определяет данное потенциальное силовое поле. Значение силы в любой точке поля равно градиенту П. э., взятому со знаком минус; поверхность $\Pi = \text{const}$ являются поверхностями уровня. Работа сил поля при перемещении системы из положения, где П. э. равна Π_1 в положение, где П. э. равна Π_2 , будет $A_{12} = \Pi_1 - \Pi_2$.

С. М. Торк.

Для системы материальных точек полная энергия (Гамильтонова функция) есть сумма кинетической и П. э. Вообще говоря, это разбиение несомненно, но обычно полагают, что П. э. — это часть суммы, зависящая только от координат. Для систем, не имеющих непосредств. механич. аналога, П. э. — это сложное в выражении для полной энергии системы, зависящее только от обобщённых координат. Напр., для плотности энергии эл.-магн. поля в вакууме $(E^2 + H^2)/8\pi$ член $H^2/8\pi$, не зависящий от обобщённых импульсов E , играет роль П. э.

В квантовой теории ф-ция Гамильтона становится оператором Гамильтона (гамильтонианом). Его часть $U(q)$, зависящая только от координат (операторов) q_i , интерпретируется как оператор П. э. Реализация операторов П. э. зависит от выбора представления; в координатном представлении — это просто оператор умножения на числовую ф-цию $U(q)$. В др. представлениях вид оператора П. э. может быть более сложным: напр., в импульсном представлении — это дифференц. оператор $U(\partial/\partial p)$.

В. П. Павлов.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЯМА — короткодействующий потенциал взаимодействия частиц, отвечающий их притяжению. Термин «П. я.» происходит от вида графика, изображающего зависимость потенц. энергии U частицы в силовом поле от её положения в пространстве (в случае одномерного движения — от координаты x). Характеристиками П. я. являются её ширина a (расстояние, на к-ром проявляется действие сил притяжения) и глубина U_0 , равная разности между значением потенц. энергии на бесконечно большом расстоянии (обычно принимаемым за нуль) и её мин. значением внутри ямы (рис. 1). Примером П. я. может служить

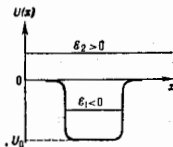
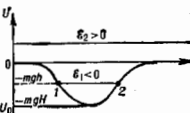


Рис. 1. Схематическое изображение потенциальной ямы $U(x)$ (\mathcal{E} — полная энергия частицы).

потенциал притяжения между протоном и нейтроном, экспоненциально убывающий с увеличением расстояния между ними.

В классич. механике частица с энергией $\mathcal{E} < 0$ не сможет вылететь из П. я. и будет всё время двигаться в огранич. области пространства внутри ямы (между двумя классич. точками остановки $U_0 = \mathcal{E}$). Положение частицы на «дне» ямы отвечает устойчивому равновесию и соответствует нулевой кинетич. энергии частицы. Если $\mathcal{E} > 0$, то частица преодолевает действие сил притяжения и свободно покидает яму. Пример — движение упругого шарика, находящегося в поле сил земного притяжения, в обычной яме с жёсткими пологими стенками (рис. 2).

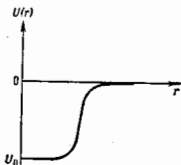
Рис. 2. Шарик массы m с энергией $\mathcal{E} < 0$ не может покинуть яму глубиной $U_0 = -mgh$ (g — ускорение свободного падения, h — высота обычной ямы, в которую попал шарик) и будет совершать колебания между точками 1 и 2 (если пренебречь трением), поднимаясь лишь до высоты $A = h - |\mathcal{E}|/mg$ над дном потенциальной ямы. Если энергия шарика $\mathcal{E}_1 > 0$, то он покинет яму и уйдёт на бесконечность с постоянной скоростью v , определяемой из соотношения $mv^2/2 = \mathcal{E}$.



В квантовой механике, в отличие от классической, энергия частицы, находящейся в связанном состоянии в П. я., может принимать лишь определённые дискретные значения, т. е. существуют дискретные уровни энергии. Однако дискретность уровней становится заметной лишь для систем, имеющих макроскопич. размеры и массы. По порядку величины расстояние $\Delta\mathcal{E}$ между уровнями для частицы массы m в «глубокой» яме шириной a определяется величиной $\Delta\mathcal{E} \sim h^2/ma^2$. Наннивший (основной) уровень энергии лежит выше «дна» П. я. (см. Нулевая энергия). В П. я. малой глубины ($U_0 \leq h^2/ma^2$), имеющей вид, изображённый на рис. 3, связанное состояние может вообще отсутствовать. Так, протон и нейтрон с антипараллельными спинами не образуют связанной системы, несмотря на существование сил притяжения между ними. Аналогичным образом не существует связанного состояния двух нейтронов — бинейтрона. В то же время при взаимодействии нейтрона и протона с параллельными спинами параметры П. я. допускают существование одного слабо связанного состояния — дейтрона.

Для случая одномерной П. я. (в отсутствие сил отталкивания) всегда существует по крайней мере одно связанное состояние. Аналогичная ситуация имеет

Рис. 3. Потенциальная яма в трехмерном случае. При $r = 0$ потенциал имеет характер бесконечной «стенки», отталкивающей частицу.



место для двумерной П. я., что имеет важное значение для существования куперовских пар (см. *Купера эффект*).

При наличии сил отталкивания (П. я. типа кратера вулкана) связанное состояние может отсутствовать в одномерном случае.

Рассеяние медленных частиц на П. я. ($ka \ll 1$, где $k = 1/\lambda$ — волновое число) может быть описано в рамках т. н. теории эфф. радиуса, использующей параметры П. я. (независимо от её конкретной формы).

Лит. см. при статьях *Нелинейная механика, Квазиклассическое приближение, Твёрдое тело, Ядро атома.*

С. С. Герштейн.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАССЕЯНИЕ частиц — рассеяние частиц, в процессе к-рого не возникает промежуточной стадии образования компаунд-системы (рассеивающий центр + частица) с последующим её распадом. В отличие от резонансного рассеяния характеризуется плавной зависимостью его сечения от энергии частиц. См. *Рассеяние микрочастиц, Рассеяние нейтронов.*

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ — безвихревое движение жидкости или газа, при к-ром каждый малый объём деформируется и перемещается поступательно, но не имеет вращения (вихря). При П. т. проекции скорости v частицы жидкости на оси координат представляются в виде частных производных

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad v_z = \frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

от ф-ции φ координат и времени, наз. потенциалом течения. Движение реальных жидкостей и газов будет потенциальным в тех областях, в к-рых действие сил вязкости ничтожно мало по сравнению с действием сил давления (жидкость считается идеальной) и в к-рых нет завихрений, образующихся за счёт срыва со стенок пограничного слоя или за счёт неравномрного нагревания. Необходимыми и достаточными условиями потенциальности течения являются равенства

$$\frac{\partial v_x}{\partial y} = \frac{\partial v_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial v_x}{\partial z} = \frac{\partial v_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial v_y}{\partial z} = \frac{\partial v_z}{\partial y}.$$

Простейшими примерами П. т. служат поступат. течение с пост. скоростью v_{x0} вдоль оси x ($v_x = v_{x0}$, $v_y = v_z = 0$, потенциал $\varphi = v_{x0}x + \text{const}$), а также источник и сток в пространстве, для к-рых $\varphi = -Q/4\pi r$, где Q — постоянная ($Q = \text{const}$) или переменная ($Q = Q(t)$) мощность источника (стока), $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ — расстояние от начала координат. При $Q > 0$ жидкость вытекает из начала координат во всех направлениях (точечный источник), а при $Q < 0$ — втекает в начало координат (сток).

Движение идеальной жидкости, возникшее из состояния покоя, будет потенциальным; будучи потенциальным в к.-л. момент времени, оно будет потенциальным и в последующее время, если давление зависит только от плотности и массовые силы являются консервативными (см. *Консервативная система*). Движение идеальной несжимаемой (плотность $\rho = \text{const}$) жидкости, вызванное мгновенным приложением импульсных давлений (внезапное движение погружённого тела,

удар тела о поверхность жидкости), будет также потенциальным.

Для П. т. дифференц. ур-ния движения идеальной жидкости приводятся к интегралу Лагранжа — Коши:

$$-\frac{\partial \varphi}{\partial t} + P + \int \frac{d\rho}{\rho} + \frac{1}{2} \left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \right) = f(t), \quad (1)$$

где P — потен. энергия поля массовых сил, приходящаяся на единицу массы, $f(t)$ — произвольная ф-ция от времени t .

Для установившегося движения соотношение (1) принимает вид

$$P + \int \frac{d\rho}{\rho} + \frac{v^2}{2} = C, \quad (2)$$

где C — постоянная для всей области П. т. сжимаемой жидкости. Т. о., для изучения П. т. достаточно определить потенциал скоростей с помощью *неразрывности уравнения*, соотношения (2) и ур-ния физ. состояния. Для несжимаемой жидкости ур-ние неразрывности имеет вид

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0,$$

и поэтому изучение П. т. сводится к решению ур-ния Лапласа

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

с учётом граничных условий на твёрдых стенках и на свободной поверхности (условий безотрывности обтекания твёрдых стенок и условия постоянства давления на свободной поверхности).

Для плоскопараллельного П. т. несжимаемой жидкости ур-ние неразрывности позволяет ввести ф-цию тока ψ

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x},$$

к-рая в комбинации с потенциалом скоростей φ составляет комплексный потенциал $W = \varphi + i\psi$, представляющий ф-цию от комплексного переменного $z = x + iy$. С помощью комплексного потенциала скоростей изучаются безотрывное обтекание плоского контура, струйное обтекание стенок и волновое движение. Безотрывное П. т. вокруг плоского контура может быть бесциркуляционным или циркуляционным. В первом случае результирующее воздействие жидкости на плоский контур равно нулю (см. *Д'Аламбера — Залера парадокс*), во втором — результирующее воздействие потока жидкости на контур сводится к *подъёмной силе*, а в случае струйного П. т. вокруг плоского контура — к силе сопротивления, пропорциональной квадрату скорости.

П. т. имеет место также при движениях сжимаемой жидкости или газа, представляющих собой малые возмущения некоего известного состояния равновесия или движения, напр. при распространении звука в среде; при этом малый избыток давления над давлением в состоянии равновесия среды связан с потенциалом скоростей соотношением $p = -\rho_0 \partial \varphi / \partial t$, а из ур-ния неразрывности в случае, когда потенциал массовых сил не зависит от времени, получается волновое ур-ние

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right),$$

где c — скорость распространения звука, вычисленная для невозмущённого состояния покоя: $c^2 = (dp/d\rho)_0$. Для П. т. газа при адиабатич. законе дифференц. ур-ние для потенциала скоростей становится нелинейным, но с помощью преобразования С. А. Чаплыгина оно приводится к линейному ур-нию, разрешаемому в ряде случаев.

Лит.: Кочи Н. Е., Кибель И. А., Рове Н. В. Теоретическая гидромеханика, 6 изд., ч. 1, М., 1983; Дойдковский Л. Г., Механика жидкости и газа, 6 изд., М., 1987; Седов Л. И., Механика сплошной среды, 4 изд., т. 1 — М., 1983.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ — поле сил $F(q)$, заданное в области Q конфигурационного пространства как градиент скалярной ϕ -функции: $F = -\text{grad}U(q)$, где $q = q_1, \dots, q_n$ (обобщённые) координаты, $U(q)$ — потенциальная энергия. Работа P с. по любому замкнутому контуру в Q , стягиваемому в точку, равна нулю. Признаком потенциальности сил является обращение в нуль их ротора, т. е. $\text{rot} F = 0$.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР — область повышенного значения потенциальной энергии, разделяющая области с пониженным её значением (потенциальные ямы и долины). Классич. система может преодолеть П. б., получив извне необходимое кол-во энергии. Такой способ преодоления барьера носит назв. аквационного. Если система находится в равновесии с термостатом при темп-ре T , много меньшей, чем высота Δ П. б., то термоактив. процесс с подавляющей вероятностью перебарывает систему через П. б. в малой окрестности перебарывающей точки, к-рой соответствует высота Δ . Вероятность w термоактив. процесса определяется ф-лой

$$w = v \exp(-\Delta/T),$$

где предкоэффициент v многократ зависит от деталей динамики, и релаксационных процессов вблизи точки передела, но экспонента является универсальной.

Квантовая механика допускает возможность проникновения сквозь П. б. частицы (системы), обладающей энергией $\epsilon < \Delta$ вследствие неопределённости энергии за конечный промежуток времени. Такой процесс наз. квантовым туннелированием (см. Туннельный эффект). Представление о квантовом туннелировании впервые введено Дж. Гамоном (G. Gamov) в 1927 для объяснения α -распада радиоакт. ядер.

ПОТЕРИ МАГНИТНЫЕ — эл.-магн. энергия, превращающаяся в теплоту в образце магнитоупорядоченного вещества при его перемагничивании перем. магн. полем H . Существует неск. механизмов П. м. Наиб. универсальный из них, характерный для широкого класса магнитоупорядоченных веществ, связан с гистерезисом магнитных. При циклич. перемагничивании образцов в результате отставания изменения намагниченности M от изменения H , связанного с общими причинами магн. гистерезиса, зависимость M от H в координатах H, M имеет вид замкнутой петли (петли гистерезиса). Это означает, что лишь часть энергии, передаваемая образцу внеш. полем при намагничивании, возвращается им при размагничивании. Др. часть превращается в теплоту, теряется. Мерой термоякой энергии служат площадь петли. Эти потери, существующие даже при квазистатич. перемагничивании, наз. гистерезисными потерями (ГП). При расчёте на один цикл перемагничивания плотность энергии Q_T , связанная с ГП, может быть определена по ф-ле

$$Q_T = \oint H \text{d}M, \quad (1)$$

где интегрирование ведётся по замкнутой петле гистерезиса. Часто вводят также мощность потерь в единицу объёма $W_T = jQ_T$ (f — частота изменения магн. индукции) и уд. потери $P_T = W_T/\rho$, где ρ — плотность вещества.

В проводящих ферромагнетиках, в частности в таких практически важных, как эл.-тех. стали, помимо ГП важную роль играют также потери на вихревые токи. Механизм возникновения таких токов и ферромагн. металлах связан с изменением магн. индукции B за счёт движения доменных стенок (ДС) под действием H . В процессе динамич. перемагничивания ДС, смешаясь, могут сильно изгибаться, а доменная

структура — дробиться и коренным образом перестраиваться. Всё это решаемым образом сказывается на той части уд. П. м. P_T , к-рая обусловлена вихревыми токами. Экспериментально установлено, что P_T величинным образом зависит от частоты f и ширины доменов L , а также имеет немонотонную зависимость от угла между осью лёгкого намагничивания и направлением H . Расчёт P_T представляет большие трудности (из-за сложности учёта динамики ДС) и может быть выполнен лишь в простейших случаях, напр. для очень тонкого проводящего ферромагн. монокристаллич. листа с плоскостью поверхности, параллельной кристаллографии, плоскости типа $\{110\}$. В случае перемагничивания этого листа вдоль направления $\{100\}$, лежащего в плоскости его поверхности, приближённый расчёт даёт

$$\frac{P_T}{P_T^{**}} \approx 1,63 \frac{L}{d}, \quad P_T^{**} = \frac{1}{6} \frac{(\pi f d B_m)^2}{\rho_0 c^2}, \quad (2)$$

где P_T^{**} — т. е. классич. П. м., вычисленные без учёта влияния ДС, B_m — амплитудное значение индукции, c — скорость света, d — толщина кристалла, ρ_0 — уд. эл.энтр. сопротивление. Из ф-лы (2) следует, что при прочих равных условиях P_T тем меньше, чем меньше L . Детальный учёт динамики ДС даёт для полных потерь $P = P_T + P_m$ результаты, согласующиеся с экспериментом, и тем самым решает проблему т. в. допозит. потерь (отличие величины $P_T + P_m^{**}$ от измеренных уд. потерь).

В поликристаллич. магнитоупорядоченных веществах большая часть П. м. приходится на P_T . Для уменьшения P_T в сталях обычно создают *магнитную текстуру*. Однако при высокосовершенной текстуре велик размер кристаллич. зёрен, а следовательно велико L , что отрицательно сказывается на P_T . Т. о., для уменьшения P необходима оптим. текстура. P_m , а также P немонотонно зависят от угла наклона β плоскости листа к плоскости $\{110\}$. Наим. значение полных П. м. соответствует углу $\beta \approx 2-3^\circ$ при отсутствии разориентации кристаллов в плоскости листа. Для уменьшения P_m на листы эл.-тех. стали наносят магнитоактивные покрытия, к-рые не только выполняют роль электроизоляции, но и при соответствующем подборе коэф. термич. расширения приводят также к растяжению листов, что уменьшает P_m и снижает P .

Обычно внизу справа у буквы, обозначающей П. м., пишут дробный индекс. Числитель его указывает индукцию в теслах, знаменатель — частоту в герцах. Так, $P_{T,1,70}$ — это уд. П. м., измеренные при индукции 1,7 Тл и частоте 50 Гц. В лучших марках стали, выпускаемых в мире, $P_{T,1,70} = 0,82$ Вт/кг при толщине листа 0,22 мм.

В металлич. ферромагнетиках помимо гистерезисных потерь иногда оказываются существенными потери, связанные с разл. процессами релаксации магн. момента: спин-спиновой релаксации и спин-решёточной релаксации (см. Релаксация магнитная).

Лит.: Дружинин В. В. Магнитные свойства электротехнической стали, 2 изд., М., 1974; Зайков В. А., Филлипов Б. Н., Шуру И. С. Доменная структура и электромагнитные потери в трансформаторной стали, в сб.: Структура и свойства электротехнической стали, Труды ИОМ, в. 33, Свердловск, 1977; Филипов Б. Н., Тажиев А. П. Динамические эффекты в ферромагнетиках с доменной структурой, М., 1987.

ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ — оттошение энергии, переносимой эл.-магн. излучением через к-л. поверхность, ко времени переноса, значительно превышающему период эл.-магн. колебаний. П. и. — силовым понятием мощности излучения; характеризует энергию излучения, распространяющегося внутри некоего телесного угла через к-л. поверхность в единицу времени. П. и. измеряется в Вт и оценивается по действию излучения на неселективный спектрально-избират. приёмник. В метрологии таким приёмником, как правило, служит калориметр с приёмным элементом в виде чер-

вёной полости, коэф. поглощения k -рой близков к единице и с достаточной для практик. целей точностью не зависит от длины волны λ . Для характеристики действия оптич. излучения на селективный приёмник (глаз человека, биол. объект и т. п.) пользуются понятием редуцированногo П. и., примером к-рого является световой поток, характеризующий действие излучения на глаз человека и измеряемый в люменах (лм). Отношение П. и. к-л. монохроматич. излучения к содержащемуся в нём световому потоку наз. *мезафизическим эквивалентом света*; 1 Вт излучения с $\lambda = 555$ нм соответствует световому потоку, равный 683 лм.

Лит.: ГОСТ 26148-84. Фотометрия. Термины и определения; Гуревич М. М., Фотометрия, 2 изд., Л., 1983.

М. А. Бузшуб.

ПРАВИЛА СУММ — теоретич. соотношения, фиксирующие значение лек-рой суммы (интеграла) матричных элементов, характеризующих переходы между состояниями рассматриваемой системы. Широкое применение П. с. в физике связано с тем, что во мн. случаях их теоретич. соображений удается вычислить лишь Нек-рую сумму физ. матричных элементов, но каждый отд. член суммы теоретически не вычисляется. Однако оно может быть измерен экспериментально. Т. о. возникает возможность проверки теоретич. принципов, лежащих в основе конкретного класса П. с.

Правила сумм в квантовой механике и квантовой теории поля. По-видимому, существование П. с. обусловлено вероятностным характером предсказаний квантовой механики. Простейшим и наиб. фундаментальным П. с. является утверждение о том, что полная вероятность найти систему в одном из возможных состояний равняется единице. В более общем виде это утверждение представляется в форме условия полноты базисного набора векторов состояний:

$$I = \sum_{\xi} |\xi\rangle \langle \xi|, \quad (1)$$

где I — единичный оператор, $|\xi\rangle$ — вектор состояния, описывающий систему в состоянии с полным набором собств. значений ξ , причём ξ может пробегать как дискретный, так и непрерывный ряд значений; $\langle \xi|$ — комплексно сопряжённый вектор («кэт» и «бра» векторы Дирака).

Выход П. с. подразумевает переход от операторного соотношения (1) к матричным элементам. Стандартным приёмом служит рассмотрение некого перестановочного соотношения, напр.:

$$[\hat{x}_k, \hat{p}_l] = i\delta_{kl}, \quad [\hat{x}_k, \hat{H}] = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}_k, \quad (1a)$$

где \hat{x}_k, \hat{p}_l ($k, l = 1, 2, 3$) — операторы компонент координаты и импульса, \hat{H} — гамильтониан, m — масса (здесь и далее постоянная Планка \hbar принята равной единице). Обращаясь к матричному элементу (1a) по нек-рому состоянию j и получая (1), получаем П. с.

$$\sum_j \langle j | \hat{x}_k | f \rangle \langle j | \hat{p}_l | i \rangle - \langle j | \hat{p}_l | f \rangle \langle j | \hat{x}_k | i \rangle = i\delta_{kl}, \quad (2)$$

где

$$\langle j | \hat{x}_k | f \rangle (e_j - e_f) = -\frac{i}{m} \langle j | \hat{p}_k | f \rangle,$$

здесь e_j, e_f — энергии состояний $|f\rangle, |i\rangle$ (М. Борн, М. Борн, В. Гейзенберг, W. Heisenberg, П. Йордан, P. Jordan, 1926).

Наиб. известным частным случаем соотношений (2) является П. с. Томаса — Райхе — Кюна (W. Thomas, F. Reiche, W. Kühn, 1925) для вероятностей дипольных (электрических) радиан. квантовых переходов в атомах:

$$\sum_n \omega_n \langle 1S | d | nP \rangle^2 = 3r_0^2,$$

где вектор $|1S\rangle$ описывает атом в осн. состоянии $1S$, $|nP\rangle$ описывает атом в P -состоянии с гл. квантовым числом n ; $r_0 = (e^2/m_0)^{1/2}$ — классич. радиус электрона, ω_n — частота перехода $nP \rightarrow 1S$, $d_k = ez \cdot k$. Если выразить вероятности переходов через соответствующие силы осцилляторов, получим др. форму записи П. с. Томаса — Райхе — Кюна (см. *Сила осциллятора*).

Подобный метод вывода П. с. получил широкое распространение в физике адронов. Исходными при этом являются перестановочные соотношения между операторами реал. векторных (см. *Векторный ток*) и аксиальных токов адронов, или *Алгебра токов*. Необходимость обращения к всемог. объектам — токам связана с тем, что наблюдаемые адроны не являются фундам. объектами и с точки зрения квантовой теории поля описываются сложной (и неизвестной) волновой ф-цией элементарных составляющих — кварков и глюонов. Что касается токов, то они, с одной стороны, являются простыми ближайшими комбинациями фундам. полей кварков, с др. стороны — их матричные элементы могут быть измерены в слабых и эл.-магн. переходах между вдрами. В частности, рассмотрение перестановочных отношений между компонентами *электромагнитного тока* адронов приводит к П. с. Дрелла — Хёрна — Герасимова (S. Drell, A. Hearn, С. В. Герасимов, 1966):

$$\int_0^\infty \frac{d\nu}{\nu} [\sigma_P(\nu) - \sigma_A(\nu)] = \frac{2\pi^2}{m_p^2} k_p^2,$$

где $\sigma_{P,A}$ — полное сечение взаимодействия фотона (с энергией ν) с поляризов. протоном; причём спин фотона параллелен (P) или антипараллелен (A) спину протона, k_p — аномальный магнитный момент протона ($k_p \approx 1.79$), m_p — масса протона. Возможности эксперим. проверки П. с., следующих из алгебры токов, значительно облегчаются применением гипотезы аксиального тока частичного сохранения:

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} A_\mu^I(x) = m_\pi^2 F_\pi \pi(x), \quad (3)$$

где $A_\mu^I(x)$ — аксиальный ток кварков в состоянии с изотопич. спином $I = 1$, F_π — константа распада $\pi \rightarrow \nu\bar{\nu}$, m_π — масса π -мезона, $\pi(x)$ — поле π -мезона. Предполагается также, что π -импульс, переносимый током, близок к нулю. Соотношение (3) позволяет во мн. случаях перейти от матричных элементов аксиального тока, к-рые экспериментально известны лишь в небольшом числе случаев, к амплитудам с участием π -мезонов.

Наиб. известным следствием алгебры операторов аксиальных токов и гипотезы частичного сохранения аксиального тока является правило сумм Адлера — Вайсбергера (S. Adler, W. Weisberger, 1965):

$$\int_{m_\pi}^\infty \frac{k dv}{\nu^2} [\sigma_{\pi^+ p}(\nu) - \sigma_{\pi^- p}(\nu)] = \frac{g_A^2 m_\pi^2}{2m_p^2} \left(1 - \frac{1}{g_A^2}\right), \quad (4)$$

где k, ν — импульс и энергия π -мезона в лаб. системе, $\sigma_{\pi^+ p}$ — полное сечение взаимодействия π^+ с протоном, g_A — аксиальная константа бета-распада нейтрона ($g_A \approx -1.2$), $g_{\pi N}$ — константа связи π -мезона с нуклоном ($g_{\pi N} \approx 14.6$).

Особенно наглядный характер имеют П. с. в модели партоное P. Фейнмана (P. Feynman, 1970). Так, для ядра протона можно написать

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} \left[\frac{2}{3} u(x) - \frac{2}{3} \bar{u}(x) - \frac{1}{3} d(x) + \frac{1}{3} \bar{d}(x) - \frac{1}{3} s(x) + \frac{1}{3} \bar{s}(x) \right] = 1, \quad (5)$$

где u, d, s ($\bar{u}, \bar{d}, \bar{s}$) — ф-ции распределения u, d, s -кварков (антикварков) в протоне, x — доля импульса протона, приходящаяся на партон; нормировка такова, что каждый член в левой части (5) имеет смысл числа соответствующих кварков (антикварков). Ф-ции распределения кварков могут быть выражены через сечения *глубоко неупругих процессов* в доступных непосредств. эксперим. определению. П. с. (5) позволяют убедиться, что целочисленный заряд адронов составлен из дробных зарядов кварков. В 1988 с помощью подобных соотношений измерена доля спина протона, приходящаяся на кварки. Оказалось, что, вопреки наивным ожиданиям, она близка к нулю. Этот результат получил назв. «спиновой кризис» и указывает на необходимость учёта вклада глюонов в спин нуклона. Более конкретной формулировкой «спиновой кризиса» является близость к нулю матричного элемента от изотопически синглетного аксиального тока по протону:

$$\langle p | \bar{u}\gamma_5\gamma_3 u + \bar{d}\gamma_5\gamma_3 d + \bar{s}\gamma_5\gamma_3 s | p \rangle = (0 \pm 0, 2) \bar{p}\gamma_5\gamma_3 p,$$

где γ_3, γ_5 — Дирака матрицы, p — волновая ф-ция протона; u, d, s — волновые ф-ции кварков.

П. с. для адронов имеют, строго говоря, интегральный характер, поскольку спектр в расщеплении частиц непрерывен. Однако реально в П. с. доминируют, как правило, резонансы с наименьшей массой. Так, в П. с. Адлера — Вайсберга (4) в интеграле от разности сечений наб. велик вклад изобары Λ_{33} (1240). Поэтому было предложено много П. с., и к-рых интегралы уменьшаются на суммы вкладов резонансов, причём в суммах оставляют 1—2 первых члена. По-видимому, наб. известным примером такого рода является П. с. Вайсберга (S. Weinberg, 1967) для сечений аннигиляции $\gamma_e e^-$ в адроны. Из этих П. с. следует, в частности, соотношение между массами ρ - и A_1 -мезонов:

$$m_{A_1}^2 \approx 2m_{\rho}^2,$$

к-рое хорошо согласуется с результатами экспериментов.

Обнаруженная амплитудно-энергетическая возможность аппроксимации кривых для сечений вкладов отд. резонансов получила наб. общее выражение в принципе *дuality*. Согласно этому принципу, сечения могут вычисляться либо как гладкие кривые в простых, прежде всего партонных, моделях, либо как вклад резонансов. Результаты должны совпадать после усреднения вкладов резонансов по вектору характерному интервалу энергий (порядка 1 ГэВ). В частности, Дж. Сакураи (J. Sakurai, 1973) предложил след. форму сечения $\sigma_{had}(s)$ аннигиляции e^+e^- в адроны:

$$\sigma_{had}(s) = \frac{4\pi\alpha^2}{s} \sum_V \frac{m_V^2 g_V^2}{(s-m_V^2)^2 + m_V^2 \Gamma_V^2},$$

где s — квадрат полной энергии в системе центра инерции, сумма берётся по векторным мезонам, m_V — масса мезона, Γ_V — ширина его распада на e^+e^- . Предполагается далее, что при $s \rightarrow \infty$ сумма по векторным мезонам стремится к константе. Значение константы должно быть нормировано на вклад низшего состояния (ρ -мезона). П. с., следующие из принципа дуальности, хорошо согласуются с экспериментом.

Принцип дуальности получил теоретич. обоснование в точной формулировке в рамках *квантовой хромодинамики* (КХД). Эфф. константа взаимодействия КХД мала только на малых расстояниях. Связывание же кварков и глюонов в адроны происходит на расстояниях, где взаимодействие становится сильным, в результате чего ещё не удалось найти аналитич. методы вычисления характеристик адронов. Поэтому метод П. с. в приложениях к КХД и физике адронов имеет при-

нципальный характер. В качестве примера применения П. с. в КХД рассмотрим амплитуду перехода фотона в адроны и обратно. Эта амплитуда является аналитич. ф-цией единственной переменной — квадрата 4-импульса фотона q^2 . Если $q^2 > 4m_q$ (m_q — масса кварка), то возможен реальный распад фотона в адроны. Это означает, что амплитуда имеет мнимую часть. Мнимую часть не удаётся вычислить в КХД, но её можно определить экспериментально, измеряя сечение аннигиляции e^+e^- (через виртуальный фотон) в адроны. *Дисперсионных соотношений метод* позволяет определить интересующую нас аналитич. ф-цию q^2 при любых q^2 через её мнимую часть.

Рассмотрим большие отрицательные q^2 , $q^2 \approx -Q^2 < 0$. Согласно *неопределённости соотношениям*, переход в адроны или кварки в этом случае возможен лишь на короткое время $\Delta t \sim (Q^2)^{-1/2}$. Поскольку теперь речь идёт о физике малых расстояний, то амплитуду диссоциации фотона в кварки при больших Q^2 можно вычислить аналитически, пользуясь *возмущенной теорией* при малой эфф. константе взаимодействия КХД. Вычисляя эти же величины с помощью дисперсионных соотношений, получаем П. с. для сечений аннигиляции e^+e^- в адроны. Поскольку Q^2 можно менять непрерывно, то возникает непрерывное семейство П. с. Существуют разные формы записи подобных П. с. В качестве примера приведём П. с. для аннигиляции e^+e^- в адроны с полным изотопич. спином $I=1$, полученные А. И. Вайштейном, В. И. Захаровым, М. А. Шифманом (1978):

$$\begin{aligned} \int ds \exp(-s/M^2) R I^{-1}(s) &\approx \\ &\approx \frac{8}{3} M^2 \left[1 + \frac{\pi^2}{3} \left\langle 0 \left| \frac{\alpha_s}{M^2} \left(\frac{G}{G_0} \right)^2 \right| 0 \right\rangle - \right. \\ &\quad \left. - \frac{14 \cdot 32}{81 M^2} \left\langle 0 \left| \alpha_s^{1/2} q q 0 \right|^2 + \dots \right\rangle \right], \end{aligned} \quad (6)$$

где «...» означает члены более высокого порядка по M^{-2} , чем выписанные выше; M^{-2} — произвольный параметр; разумно выбрать M^2 не менее той величины, при к-рой члены M^{-4} , M^{-6} становятся сравнимы с единичной; s — квадрат энергии в системе центра инерции e^+e^- ; $R I^{-1}(s)$ — полное сечение аннигиляции e^+e^- в адроны с $I=1$ в единицах сечения $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$; α_s — константа сильного взаимодействия; G — напряжённость глюонного поля (a — индекс цвета, $a=1, \dots, 8$); *вакуумное среднее* $\alpha_s \langle (G^a)^2 \rangle$ имеет смысл интенсивности непертурбативных $q\bar{q}$ (не описываемых в рамках теории возмущений) вакуумных полей; q — поле лёгкого кварка, $q = u, d$. В отличие от $\langle (G^a)^2 \rangle$, *вакуумный конденсат* кварковых полей $\langle \bar{q}q \rangle$, к-рый также входит в (6), был введён в рассмотрение ранее в связи со спонтанным нарушением киральной симметрии.

Отметим, что в пределе $M^2 \rightarrow \infty$ из соотношения (6) следует $R I^{-1}(s) \rightarrow s^2$ при $s \rightarrow \infty$. С др. стороны, если брать возможно меньшие значения M^2 , то из-за обрабатываемого фактора $\exp(-s/M^2)$ интеграл от сечения вычисляется при относительно небольших s . Продвижение в область малых M^2 ограничивается требованием законности отбрасывания в правой части (6) члена порядка по M^{-2} . Численный анализ показывает возможность выбора таких малых M^2 , что интеграл от сечения на 90% насыщается вкладом одного ρ -мезона. Так возникает эфф. теория одного отд. резонанса в КХД.

Лит.: Бете Г., Солднер Э., Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами, пер. с англ., М., 1980; Bernstein J., Elementary particles and their currents, S. F. — L., 1968, ch. 12; Новиков В. А. и др. Gluons and gluons, «Phys. Repts.», 1978, v. 41C, N 1. В. И. Захаров.

Правда суммы в статистич. ф-циях. Основой вывода и применения П. с. в этом случае являются спектральные представления двумерных корреляц. ф-ций (см. Грина функция в статистич. физике)

$$\langle A(t), B(t') \rangle = \langle A(t)B(t') - \eta B(t')A(t) \rangle =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} I_{BA}(\omega) \{ \exp(\beta\omega\hbar) - \eta \} \exp[-i\omega(t-t')] d\omega \quad (7)$$

Здесь $A(t)$, $B(t')$ — операторы в Гейзенберга представлении, $\eta = \pm 1$, $\beta = 1/kT$, (...) — обозначает усреднение по большому каноническому распределению Гиббса, $\langle A \rangle = \text{Sp}(\rho A) / \text{Sp} \rho$, $\rho = \exp[-\beta(H - \mu N)]$ — статистич. оператор (Sp — символ суммы диагональных матричных элементов оператора), H — оператор Гамильтона, μ — хим. потенциал, N — оператор числа частиц. Спектральная плотность

$$I_{BA}(\omega) = \sum_{l,m} \langle m | B | l \rangle \langle l | A | m \rangle \delta(\hbar\omega - \mathcal{E}_m - \mathcal{E}_l) \quad (8)$$

обобщает соотношение (2) при получении П. о. для произвольной пары операторов динамики. переменных $[A, B]$ — собств. значения гамильтониана H , соответствующие векторам состояния $|m\rangle$ и $|l\rangle$, $\delta(\hbar\omega - \mathcal{E}_m - \mathcal{E}_l)$ — дельта-функция].

Простейшие П. с. получаются из (7) при $t' = t$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} I_{BA}(\omega) \{ \exp(\beta\omega\hbar) - \eta \} d\omega = \langle [A, B] \rangle$$

Дифференцируя n раз по t (или t') и полагая $t = t'$, можно получить бесконечный набор П. с.

$$\frac{(-i\hbar)^n}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \omega^n I_{BA}(\omega) \{ \exp(\beta\omega\hbar) - \eta \} d\omega = \langle [\frac{\partial^n A(t)}{\partial t^n}, B(t')] \rangle, \quad (9)$$

выражающих моменты спектральной плотности через оператор. корреляц. ф-ции. Правые части этих соотношений вычисляются точно, т. к. $\partial A / \partial t = -i\hbar^{-1}[A, H]$, где $\eta = 1$, тогда $\partial^n A(t) / \partial t^n$ представляет собой n -кратный коммутатор. Выражение (9) используется для практ. построения спектральной плотности $I_{BA}(\omega)$ в виде разложения по моментам, а также проверки корректности аппроксимаций $I_{BA}(\omega)$. П. с. эффективно служат для описания свойств обобщенной восприимчивости системы $\chi_{BA}(k, \omega)$, для к-рой справедливо спектральное представление

$$\chi_{BA}(k, Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I_{BA}(k, \omega') \{ \exp(\beta\omega'\hbar) - 1 \} d\omega'}{\omega' - Z}, \quad (10)$$

где $Z = \omega + i\epsilon$, $\epsilon \rightarrow 0$ в соответствии с принципом причинности. Ф-ция (10) описывает линейную реакцию системы на обобщенное внеш. поле, зависящее от координаты r и времени t и характеризующееся частотой ω и волновым вектором k . Применение асимптотич. разложения $(1 - \omega/Z)^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \omega^n Z^{-n}$ даёт

$$\chi_{BA}(k, Z) = \sum_{n=1}^{\infty} Z^{-n} \chi_{BA}^{n-1}(k),$$

для моментов $\chi_{BA}^{n-1}(k)$ существуют П. с., аналогичные (9):

$$\chi_{BA}^{n-1}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \omega^{n-1} I_{BA}(k, \omega) \{ \exp(\beta\omega\hbar) - 1 \} d\omega.$$

Из спектрального представления (10) следует формулировка флуктуационно-диссипативной теоремы, являющейся обобщением Крамера — Кроуича соотношений на случай конечных темп-р и связывающей действительную χ' и мнимую χ'' части обобщенной восприимчивости:

$$\chi'_{BA}(k, \omega) = P \int_{-\infty}^{\infty} I_{BA}(k, \omega') \{ \exp(\beta\omega'\hbar) - 1 \} (\omega' - \omega)^{-1} d\omega';$$

$$\chi''_{BA}(k, \omega) = \pi I_{BA}(k, \omega) \{ \exp(\beta\omega\hbar) - 1 \},$$

где P — символ гл. значения интеграла, поэтому

$$\chi'_{BA}(k, \omega) = \pi^{-1} P \int_{-\infty}^{\infty} \chi''_{BA}(k, \omega') (\omega' - \omega)^{-1} d\omega'.$$

Статич. предел ($\omega = 0$) даёт П. с. для неоднородной восприимчивости $\chi'_{BA}(k)$:

$$\chi'_{BA}(k) = \pi^{-1} P \int_{-\infty}^{\infty} \chi''_{BA}(k, \omega) \omega^{-1} d\omega. \quad (11)$$

В однородном пределе ($k = 0$, $\omega = 0$) могут быть получены термодинамические П. с. При $k \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow 0$ величина χ_{BA} является измеряемой на опыте адиабатической (при пост. энтропии S) восприимчивостью χ_{BA}^T (реакции функции), характеризующей изменение (реакцию) физ. величины (или оператора) A на действие постоянного и однородного внеш. поля, термодинамически сопряжённого внутр. параметру B . Для большинства эргодических физ. величин (см. Эргодическая гипотеза) χ_{BA}^T совпадает с изотермич. восприимчивостью χ_{BA}^T . Величина χ_{BA}^T , пропорц. корреляционной ф-ции флуктуаций A и B , совпадает со второй производной свободной энергии F по обобщённым полям, термодинамически сопряжённым A и B . Для эргодических систем согласование между динамич. и термодинамич. свойствами обеспечивается П. с.

$$\chi_{BA}^T = \chi_{BA}^T = \lim_{k \rightarrow 0} P \int_{-\infty}^{\infty} I_{BA}(k, \omega) \{ \exp(\beta\omega\hbar) - 1 \} \omega^{-1} d\omega. \quad (12)$$

Наиб. распространённые примеры применения этого П. с.: магн. системы, где $A = M_z$, $B = M_z$ — проекция вектора намагниченности на ось координат, $\chi_{BA}^T = \chi_{\text{об}}$ — тензор магн. восприимчивости; проводники, где $A = J_z$, $B = J_z$ — проекция вектора плотности тока, $\chi_{BA}^T = \chi_{\text{об}}$ — тензор электропроводности; изотропные газы и жидкости, где $A = B = \rho$ — плотность частиц, внеш. поле — давление, $\chi_{BA}^T = \chi_{\text{об}}$ — сжимаемость, определяемая флуктуациями числа частиц; любые физ. системы, где $A = B = \mathcal{E}$ — энергия системы, роль внеш. поля играет обратная темп-ра, $\chi_{BA}^T = \chi_{\text{об}}$ — теплоёмкость, определяемая флуктуациями энергии.

В случае, когда один или оба локальных оператора $A(r, t)$, $B(r', t)$ являются плотностями интегралов движения [напр., $\int B(r, t) dr = \text{const}$], П. с. (12) принимает простой вид:

$$\chi_{BA}^T = \beta \lim_{k \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} I_{BA}(k, \omega) d\omega,$$

где B_k , A_k — фурье-компоненты B и A , причём

$$\lim_{k \rightarrow 0} \int B(r, t) \exp(-ikr) dr = \lim_{k \rightarrow 0} B_k(t) = B_0 = \text{const.}$$

Спектральная плотность в пределе $k \rightarrow 0$ обладает дельтаобразной особенностью (т. е. центральной пик):

$$\lim_{k \rightarrow 0} I_{BA}(k, \omega) = \langle B_0 A \rangle \delta(\omega).$$

Как видно из (8), для этого необходимо вырождение системы (т. е. $\epsilon_m = \epsilon_l$ при $m \neq l$).

Приведённые П. с. применяются при анализе прямых экспериментов по измерению спектральной плотности $I_{BA}(k, \omega)$: для рассеяния алектронов $A = B = \sigma$ — плотность заряда; для нейтронов $A = B = n$ — плотность частиц при потенциальном рассеянии и $A = M_x$, $B = M_y$ при магн. рассеянии; для рассеяния света $A = P_x$, $B = P_y$ — проекция вектора поляризации среды.

П. с. весьма существенны при доказательстве и практич. применении теорем квантовой статист. механики — *Боголюбова теорем* и *Годстоуна теорем*, отражающих глобальные свойства симметрии системы. Эти теоремы наряду с П. с. используются при рассмотрении гидродинамики простой и сверхтекучей жидкостей, сверхпроводимости, жидких кристаллов, синих волец в магнетиках и т. п.

Лит.: Зубарев Л. Н., Неравновесная статистическая термодинамика, М., 1971; Боголюбов Н. (мл.), Садовиков В. И., Некоторые вопросы статистической механики, М., 1975; Фортстер Д., Гидродинамические флуктуации, нарушающие симметрию в корреляционных функциях, пер. с англ., М., 1980. Ю. Г. Рыбов.

ПРАЗЕДИИМ (Praseodymium), Pr, — хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 59, ат. масса 140,9077, относится к *лантаноидам*. В природе представлен ^{141}Pr . Электронная конфигурация внеш. оболочек $4s^2 4p^6 4d^9 5s^2 5p^6 6s^2$. Энергия последоват. ионизации 5,42; 10,55; 21,63; 38,96 в соответственно. Металлич. радиус атома Pr 0,182 нм, радиус иона Pr^{3+} 0,100 нм. Значение электроотрицательности 1,07.

В свободном виде П. — серебристый металл с жёлтым оттенком. До 798 °C устойчив α -Pr с гексагональной плотноупакованной структурой, параметры решётки $a = 0,3864$ нм, $c = 1,1987$ нм. Выше 796 °C устойчив β -Pr с объёмноцентрированной кубич. структурой, постоянная решётки $a = 0,413$ нм. Плотность α -Pr 6,77 кг/дм³; $t_{пл} = 982$ °C, $t_{кип}$ ок. 3500 °C, уд. теплоёмкость $c_p = 27,42$ Дж/моль·K, теплота плавления 6,90 кДж/моль, теплота испарения 298,4 кДж/моль, темп-ра Дебая 138 K. Коэф. теплопроводности α -Pr 13,2 Вт/м·K (при 293 K), термич. коэф. линейного расширения 6,8·10⁻⁶ K⁻¹ (при 298 K). Уд. электр. сопротивление 0,7 мкОм·м (при 300 K), термич. коэф. расширения 1,71·10⁻⁵ (при 273—373 K).

П. — сильный парамагнетик, магн. восприимчивость 37,80·10⁻⁶. Твёрдость по Бринеллю 392 МПа, модуль упругости 32,6 ГПа, модуль сдвига 13,5 ГПа. По хим. свойствам схож с др. лантаноидами, степень окисления +3, реже +4. При повышении темп-ры образуется оксид Pr₂O₃. При повышении темп-ры металл. П. способен поглощать значит. кол-во водорода. Входит в состав мышьяка и др. (в частности, магнитных) сплавов. Оксид П. используется как катализатор хим. реакций, включается в состав спец. стёкол. В качестве радиоакт. индикатора используют β -радиоактивный ^{140}Pr ($T_{1/2} = 13,57$ сут). С. С. Вердосое.

ПРАНДТЛЯ ТРУБКА (Питю — Прандтля трубка) — прибор для одноврем. измерения полного и статич. давления в потоке жидкости или газа. Представляет собой трубку Питю, усовершенствованную нем. учёным Л. Прандтлем (L. Prandtl), к-рый совместил измерение полного и статич. давления в одном приборе. См. *Трубки измерительные*.

ПРАНДТЛЯ ЧИСЛО [по имени Л. Прандтля (L. Prandtl)] — один из *подобия критериев* тепловых процессов в жидкостях и газах $Pr = \nu/\alpha = \mu c_p/\lambda$, где $\nu = \mu/\rho$ — коэф. кинематич. вязкости, μ — коэф. динамич. вязкости, ρ — плотность, λ — коэф. тепло-

проводности, c_p — уд. теплоёмкость среды при пост. давлении.

П. ч. характеризует соотношение между интенсивности молекулярного переноса кол-ва движения и переноса теплоты теплопроводностью; является физ. характеристикой среды и зависит только от её термодинамич. состояния. У газов П. ч. с изменением темп-ры практически не меняется (для двухатомных газов $Pr \approx 0,72$, для трёх- и многоатомных — $Pr \approx$ от 0,75 до 1). У металлич. жидкостей П. ч. изменяется с изменением темп-ры тем значительно, чем больше вязкость жидкости (напр., для воды при 0 °C $Pr = 13,5$, а при 100 °C $Pr = 1,74$; для трансформаторного масла при 0 °C $Pr = 886$, при 100 °C $Pr = 43,9$). У жидких металлов $Pr \ll 1$ и ве так сильно изменяется с изменением темп-ры (напр., для натрия, при 100 °C $Pr = 0,0145$, при 700 °C $Pr = 0,0039$).

По аналогии с П. ч. вводит диффузионное число Прандтля $Pr_D = \nu/D$ (D — коэф. диффузии), характеризующее соотношение между интенсивностями молекулярного переноса кол-ва движения и переноса массы примеся диффузией (см. *Шмидта число*). При турбулентном режиме течения жидкостей и газов ввиду с молекулярным переносом кол-ва движения имеет место их турбулентный перенос, и критерий, аналогичный П. ч., наз. турбулентным числом Прандтля $Pr_T = c_{pT}/\lambda_T$, где λ_T — турбулентная вязкость и турбулентная теплопроводность. В магн. гидродинамике используются магнитное число Прандтля $Pr_M = \nu_M/\sigma_a$, где ν_M — абс. магн. проводимость среды, σ_a — электр. проводимость среды.

П. ч. связано с др. критериями подобия — *Пекле числом* Pe и *Рейнольдса числом* Re соотношением $Pr = Pe/Re$. С. Л. Вишневский.

ПРАНДТЛЯ — МАЙЕРА ТЕЧЕНИЕ — класс установившихся сверхзвуковых плоских безвихревых движений газа, характеризующийся определ. связью между составляющими v_x , v_y вектора скорости газа (см. *Сверхзвуковое течение*). П. — М. т. могут возникать, напр., при обтекании стенок с изломом, при взаимодействии между собой *стачное уплотнения*, при истечении газовых струй в пространство с пониженным давлением и в др. случаях. Важность П. — М. т. обусловлена д. особенностью тем, что любое течение, непрерывно соединяющееся с областью пост. потока, всегда есть П. — М. т. Так, течение, соответствующее обтеканию однородным сверхзвуковым потоком криволинейного выпуклого участка стенки OC_1 (рис. 1), есть П. — М. т. Поворот потока происходит постепенно в последовательности прямых характеристик, исходящих из каждой точки искривлённого участка стенки. В частном случае стенки с изломом (обтекание внешнего тупого угла, OC_1 — прямая линия) отсутствует характерный для П. — М. т. поворот потока. П. — М. т. становится *атомо-дальным течением*.

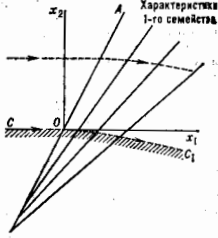


Рис. 1. Схема течения Прандтля — Майера с расширением газа (обтекание выпуклого криволинейного участка стенки).

В общем случае П. — М. т. описываются решениями системы двух квазилинейных дифференц. ур-ний в частных производных с двумя независимыми пространственными переменными x_1 , x_2 ; некоторыми функциями служат составляющие v_x , v_y вектора скорости газа. В П. — М. т. имеется определ. связь между v_x и v_y , так что область течения газа в физ. плоскости переменных x_1 и x_2 отображается в плоскости годографа скорос-

ти v_1, v_2 (рис. 2) на отрезок кривой — образ характеристики дифференц. ур-ний в плоскости течения. Для сверхзвукового газа с пост. теплоемкостями кривые 1 и 2 (эпителиклоиды) соответствуют П.—М. т. двух семейств (все другие кривые, к-рые соответствуют все возможным П.—М. т. в физ. плоскости, получаются из кривых

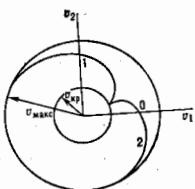


Рис. 2. Диаграмма характеристик течения Прандтля — Магера в плоскости годографа скорости. Даны 1 и 2 соответствуют течениям Прандтля — Магера равных семейств.

1 и 2 поворотом их вокруг центра и лежат между окружностями с радиусами, равными критич. $v_{кр}$ и макс. v_{max} скоростям адиабатч. движений газа). Полученная таким способом «диаграмма характеристик» в плоскости годографа дозволяет решать многие задачи о П.—М. т. графич. методом.

П.—М. т. имеет простую структуру. В течениях, соответствующих, напр., кривой 2 на рис. 2, все характеристики первого семейства в физ. плоскости течения x_1 и x_2 прямолинейны (рис. 1) и на каждой из них значения v_1, v_2 (и значения др. параметров, связанных с величиной скорости, — давления, плотности, темп-ры) неизменны. П.—М. т. имеют физ. смысл лишь в области, где не происходит пересечение прямолинейных характеристик; на рис. 1 это может быть область над линией тока CO_1 . Согласно кривой 2 на рис. 2, при повороте вектора скорости потока по часовой стрелке, как на рис. 2, величина скорости растёт и, согласно интегралу Бернулли (см. *Бернулли уравнение*), давление и плотность газа падают — происходит разрежение газа.

При обтекании вогнутого участка стенки (рис. 3) происходит сжатие газа и движение является П.—М. т. лишь в области вверх по потоку от характеристики второго семейства AC_1 , идущей из ближайшей к стенке

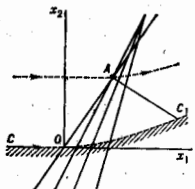


Рис. 3. Схема течения Прандтля — Магера со сжатием газа (обтекание вогнутой криволинейной стенки).

точки пересечения прямолинейных характеристик А. У точки А образуется «высвист», не примыкающий к стенке скачок уплотнения, распространяющийся внутрь области течения; поток за скачком становится вихревым.

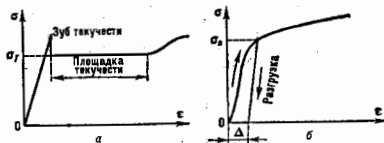
П.—М. т. описываются простыми ф-лами, полученными интегрированием упомянутых выше дифференц. ур-ний, для их расчёта имеются подробные таблицы, дозволяющие построить карту течения (линии тока) и определить все газодинамич. параметры.

Лит.: Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика 3 изд., ч. 1—2, М., 1991; Черныш Г. Г., Газовая динамика, М., 1988.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕКУЧЕСТИ в сопротивлении материалов — напряжение, при к-ром начинает развиваться пластич. деформация. В опытах с растягиваемым цилиндрич. образцом определяется нормальное

напряжение σ_0 в поперечном сечении, при к-ром впервые возникает пластич. (необратимые) деформации. Аналогично в опытах с кручением тороватого грубого образца определяется П. т. при сдвиге τ_0 . Для большинства металлов $\sigma_0 = \tau_0 \sqrt{3}$.

В нек-рых материалах при непрерывном удлинении цилиндрич. образца на диаграмме зависимости нормального напряжения σ от относит. удлинения ϵ обнаруживается т. н. зуб текучести, т. е. резкое снижение напряжения перед появлением пластич. деформации (рис., а), причём дальнейший рост деформации (пластической) до нек-рого ϵ значения происходит при неизменном напряжении, к-рое наз. физическим П. т. σ_0 . Горизонтальный участок диаграммы $\sigma \sim \epsilon$ наз. площадкой текучести; если её протяжённость велика, материал наз. идеально-пластическим (неупрочняющимся). В др. материалах, к-рые наз. упрочняющимися,



площадки текучести нет (рис., б) и точно указать напряжение, при к-ром впервые возникает пластич. деформации, практически невозможно. Вводит понятие условного П. т. σ_0 как напряжения, при разгрузке от к-рого в образце впервые обнаруживается остаточная (пластич.) деформация величины Δ . Остаточные деформации, меньше Δ , условно считаются пренебрежимо малыми. Напр., П. т., измеренный с допуском $\Delta = 0,2\%$, обозначается $\sigma_{0,2}$. См. также *Пластичность*. В. С. Лешский.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ СИММЕТРИИ — см. *Симметрия кристаллов*.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ — изолированная замкнутая траектория в фазовом пространстве динамич. системы, изображающая периодич. движение. В окрестности П. ц. фазовые траектории либо удаляются от него (неустойчивый П. ц.), либо неограниченно приближаются к нему — «наматываются» на него (устойчивый П. ц.). Поведение траекторий в окрестности П. ц. связано со значениями его мультипликаторов (см. *Вилфуркация*). Если абс. величины всех мультипликаторов меньше 1, то все траектории неограниченно приближаются к нему и он устойчив. Устойчивый П. ц. является матем. образом периодич. автоколебаний. Напр., ур-ние Ван дер Поля (описывающее, в частности, динамику лампового генератора)

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \epsilon(1-x^2) \frac{dx}{dt} + x = 0$$

имеет при значениях параметра $\epsilon > 0$ единственный устойчивый П. ц. (рис. 1).

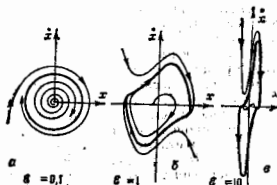


Рис. 1. Фазовые портреты генератора Ван дер Поля при различных значениях величины ϵ : а — квазигармоничные колебания; б — сильно нелинейные; в — релаксационные.

Для систем с одной степенью свободы (их фазовое пространство — плоскость) устойчивыми П. ц. и устойчивыми состояниями равновесия исчерпываются все возможные объекты, к-рые притягивают соседние траектории на фазовой плоскости. В многомерных динамич. системах с размерностью фазового пространства $n \geq 3$ возможны более сложные притягивающие объекты — аттракторы.

Если часть мультипликаторов (но не все) по модулю больше 1, то П. ц. седловой (рис. 2) и лежит на пересечении двух сепаратрисных многообразий: устойчивого,

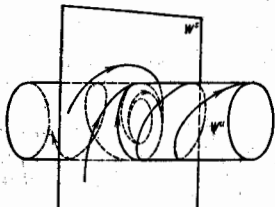


Рис. 2. Седловой предельный цикл: W^+ — устойчивое сепаратрисное многообразие; W^- — неустойчивое сепаратрисное многообразие.

по к-рому траектории приближаются к П. ц., и неустойчивого, состоящего из удаляющихся от П. ц. траекторий. Устойчивые многообразия П. ц. могут разделять в фазовом пространстве области притяжения разл. аттракторов — как простых (состояние равновесия, устойчивый П. ц.), так и странных. Неустойчивые многообразия седловых П. ц. могут входить в состав странных аттракторов и стохастич. множество гамильтоновых систем и определять их структуру. Если все мультипликаторы по модулю больше 1, то П. ц. неустойчив (устойчив при обращении направления движения по траектории, т. е. при $t \rightarrow -\infty$).

Переход через единичное значение ас. величин одного или неск. мультипликаторов при изменении параметров динамич. системы свидетельствует о бифуркации смены устойчивости или исчезновении П. ц.

Лит.: Андросов А. А., Витт А. А., Хвятикин С. Ф., Теория колебаний, 3 изд., М., 1981; Ватутин Н. Н., Демкович Е. А., Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости, М., 1978; Рабинович М. И., Трубецков С. Д. И., Введение в теорию колебаний и волн, М., 1984.

В. С. Абрамочки, М. И. Рабинович

ПРЕДИССОЦИАЦИЯ МОЛЕКУЛЫ (от лат. praе — вперед, аperi и dissociati — разделение, разделение) — безызлучательный переход возбужденной молекулы на устойчивое электронного состояния в неустойчивое с той же энергией, сопровождающийся диссоциацией молекулы. Явление П. м. легче всего наблюдается в случае двухатомных молекул и может быть объяснено на основе представления о кривых потенц. энергии $U(r)$ (см. Потенциальная поверхность). Под действием фотона с энергией $\mathcal{E} = h\nu$ (частота возбуждающего света) молекула переходит из основного электронного состояния (рис. 1, кривая 1) в возбужденное (кривая 2), откуда в результате колеб. движения молекулы возможен безызлучат. переход на кривую отталкивания (кривая 3), приводящий к распаду молекулы на атомы, т. е. к диссоциации. Согласно Фраунк-Кондону принципу, наиб. вероятен переход, соответствующий пересечению кривых притяжения и отталкивания, т. е. П. м. происходит при энергии, близкой к $\mathcal{E}_D = D_0$, где D_0 — энергия диссоциации молекулы. Кинетич. энергия тем больше, чем круче спадает кривая отталкивания при разлете атомов. Экспериментально определяемые значения r и v в пределе диссоциации и \mathcal{E}_D дают верх. предел для энергии

диссоциации D_0 . В случае пологого хода кривой отталкивания D_0 может мало отличаться от \mathcal{E}_D , напр. $\Delta = 0,12$ эВ для молекулы N_2 .

При П. м. время жизни молекулы в возбужденном состоянии с энергией, близкой к \mathcal{E}_D , сокращается. Поэтому П. м. проявляется в уширении вращат. линий в электронико-колеб. полосах поглощения (что может приводить к частичному или полному исчезновению вращат. структуры электронико-колеб. полос испускания). В случае флуоресценции это приводит к ослаблению или даже полному её исчезновению; ослабление

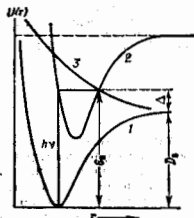


Схема предиссоциации при переходе молекулы на кривую отталкивания: 1 и 2 — кривые притяжения соответственно к основному и возбужденному электронным состояниям; 3 — кривая отталкивания; \mathcal{E}_D и D_0 — энергии предиссоциации и диссоциации соответственно; Δ — энергетич. энергия разлетающихся атомов.

флуоресценции — часто более чувствит. индикатор П. м., чем уширение линий, к-рое в случае слабой П. м. трудно обнаружить.

С квантовомеханич. точки зрения, П. м. — результат возмущения, возникающего вследствие взаимодействия дискретных уровней энергии с непрерывными. В нулевом приближении энергию молекулы можно представить в виде суммы электронной и колебательной составляющих, при этом состоянии, соответствующей кривой притяжения (дискретные состояния) и кривой отталкивания (непрерывные состояния), независим друг от друга. Согласно теории возмущений, при учете электронико-колеб. взаимодействия эти состояния уже не независимы и действит. состояние молекулы с энергией \mathcal{E} является наложением дискретного и непрерывного состояний. Волновая ф-ция, описывающая состояние молекулы, $\Psi_{\mathcal{E}} = C_1\Psi_d + C_2\Psi_n$, где C_1 и C_2 — коэф., квадраты модулей к-рых дают вероятность найти молекулу в состояниях, описываемых волновыми ф-циями Ψ_d и Ψ_n . Т. о. молекула в состоянии, описываемом волновой ф-цией $\Psi_{\mathcal{E}}$, распадается с тем большей вероятностью, чем больше C_2 . Взаимодействие возможно лишь для состояний одинаковой симметрии, что накладывает ограничения на возможность П. м.

П. м. может иметь место и для многоатомных молекул, однако её наблюдение затрудняется сложностью спектров и возможно лишь для наиб. простых из них. Для сложных молекул с широкими сплошными полосами поглощения и испускания, в к-рых отсутствует вращат. структура, предиссоциацию вообще нельзя наблюдать. Однако именно для таких молекул важна роль предиссоциации и их распада при возбуждении уровнями энергии, лежащих выше границ диссоциации, т. к. выше способов, к-рыми предиссоциация может быть осуществлена, возрастает с увеличением числа колеб. степеней свободы молекулы. Предиссоциация сложной молекулы может происходить со значит. задержкой по отношению к моменту возбуждения, т. к. её энергия распределяется по многочисл. колеб. степеням свободы, а диссоциация наступает в результате случайной концентрации колеб. энергии на наиб. слабой связи.

С П. м. может быть связана повышенная хим. активность в-за образования при предиссоциации атомов и радикалов, обладающих высокой реакционной способностью. Поэтому П. м. играет важную роль в фотохимии.

Лит. см. при ст. Молекулярные спектры. М. А. Елжечиц,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРУППЫ — изображение элементов группы матрицами или преобразованиями линейного пространства, при к-ром сохраняется исходная групповая структура. Поскольку достаточно хорошо изучены матричные группы, при исследовании произвольных групп стараются установить соответствие между её элементами и матрицами век-групп фиксиров. порядка, т. е. изучать группу с помощью её линейной модели. Рассмотрение П. г. позволяет обнаружить важные свойства самих групп.

В физике естеств. образом возникают П. г. симметрии. Рассмотрим, напр., преобразование трёхмерного пространства в результате вращений системы координат. Закон преобразования векторов $x \rightarrow x'$ даёт, разумеется, трёхмерное П. г. вращений. Инвариантность скаляров относительно вращений позволяет ввести одномерное П. г. вращений, когда каждый элемент группы отображается на тождество. Преобразование можно записать закон преобразования компонент T_{ij} тензора ранга 2. Если рассматривать 9 величин T_{ij} как координаты точки 9-мерного пространства, получим 3-мерное П. г. вращений. Пусть $T_{ij} = T_{ji}$, это свойство инвариантно относительно вращений; поскольку при этом остаётся лишь 6 компонент T_{ij} , получается 6-мерное П. г. вращений, и т. д. Аналогично можно построить П. г. Лоренца. Законы преобразования спиноров дают т. н. двузначные П. г. вращений и группы Лоренца. Симметрия или антисимметрия многочастичной волновой ф-ции при перестановке тождеств. частиц даёт П. г. перестановок. Одна из целей теории П. г. — найти реал. законы преобразования физ. величин, т. е. найти всевозможные П. г. симметрии.

П. г. тесно связаны с реал. специальными функциями матем. физики, в к-рых явно проявляются соотношения симметрии. Эта связь позволяет с единой точки зрения исследовать свойства спец. ф-ций и обнаружить новые классы ф-ций.

Развитие теории П. г. началось в кон. 19 — нач. 20 вв. в работах Г. Фробениуса (G. Frobenius) и И. Шурца (I. Schur). Затем Г. Вейль (H. Weyl), Дж. Нейман (J. Neumann) и Ю. Вигнер (E. Wigner) продемонстрировали важность этой теории для физики.

Основные определения. П. г. G в пространстве V наз. отображение $D(G, V)$ этой группы в набор преобразований V . Каждому элементу $g \in G$ ставится в соответствие оператор $T(g)$, действующий в пространстве V , причём $T(g_1 g_2) = T(g_1) T(g_2)$ для любых g_1 и g_2 из G ; $T(e) = I$, где e — единичный элемент группы G , а I — единичный оператор в V . П. г. наз. линейными, если V — линейное пространство, а $T(g)$ — линейный оператор. В дальнейшем речь будет идти только о линейных П. г. Если G — топологич. группа, то обычно требуют, чтобы $T(g)$ непрерывно зависел от g , также П. г. наз. непрерывными.

Размерность пространства V обычно наз. размерностью представления, $\dim D(G, V)$, П. г. наз. вещественными (комплексными), если пространство П. г. V — вещественное (комплексное). Если $D(G, V)$ конечномерно, то, выбрав в V базис e_1, e_2, \dots, e_n , можно задать операторы $T(g)$ матрицами n -го порядка $\|T_{ij}(g)\|$, где элементы матрицы определяются соотношением $T(g)e_k = \sum_{j=1}^n T_{jk}(g)e_j$. Матрица $\|T_{ij}(g)\|$ наз. матрицей представления $D(G, V)$, а ф-ция $T_{ij}(g)$ — матричными элементами представления.

Простейшее П. г. получается, если положить $T(g) = I$, оно наз. единичным или тривиальным. Если группа G состоит из матриц фиксиров. порядка, то одно из П. г. получается при $T(g) = g$. Т. о., определение всякой линейной группы является одномерным заданием её представления в виде группы линейных операторов, т. е. группы матриц. Такие П. г. наз. определяющими. П. г. $D(G, V)$ наз. точ-

ным, если $T(g) = I$, тогда и только тогда, когда $g = e$. В этом случае отображение $g \rightarrow T(g)$ взаимно однозначно (является изоморфизмом).

Если H — подгруппа группы G , то, рассматривая оператор $T(g)$ только при $g \in H$, получим представление $D(H, V)$, называемое сужением $D(G, V)$ на подгруппу H . Подпространство $V_1 \subset V$ наз. инвариантным относительно П. г. $D(G, V)$, если оно инвариантно относительно всех операторов $T(g)$ этого П. г., т. е. для любых $g \in G$ и $v \in V_1$, $T(g)v \in V_1$ (операторы $T(g)$ не выводят из V_1).

Два П. г. $D_1(G, V_1)$ и $D_2(G, V_2)$ наз. эквивалентными, $D_1(G, V_1) \sim D_2(G, V_2)$, если существует линейный оператор A , взаимно однозначно отображающий V_1 на V_2 и удовлетворяющий условию $A T_1(g) = T_2(g) A$ для всех $g \in G$. Если $D_1(G, V_1)$ конечномерно и $D_1(G, V_1) \sim D_2(G, V_2)$, то $\dim D_1(G, V_1) = \dim D_2(G, V_2)$ и при соответствующем выборе базиса в V_1 и V_2 матричные элементы представлений $D_1(G, V_1)$ и $D_2(G, V_2)$ совпадают.

Пусть $V_1 \subset V$ — инвариантное подпространство относительно П. г. $D(G, V)$. Тогда получаем П. г. $D_1(G, V_1)$, к-рое наз. подпредставлением П. г. $D(G, V)$. П. г. наз. приводимым, если оно содержит нетривиальные (т. е. отличные от тривиального и самого себя) подпредставления. П. г. $D(G, V)$ наз. разложимым, если содержит подпредставления $D_1(G, V_1)$ и $D_2(G, V_2)$, так же, что V изоморфно прямой сумме своих подпространств, $V = V_1 \oplus V_2$. В этом случае говорят, что П. г. эквивалентно прямой сумме представлений D_1 и D_2 : $D \sim D_1 \oplus D_2$. Если в П. г. D для всякого подпредставления D_1 существует подпредставление D_2 , так же, что $D \sim D_1 \oplus D_2$, то П. г. наз. вполне приводимым. В таком П. г. всякое инвариантное относительно действия операторов подпространство имеет инвариантное дополнение. Приводимое П. г. не обязательно должно быть разложимым.

Если в качестве базиса в пространстве V вполне приводимого конечномерного П. г. взять совокупность базисных векторов пространства подпредставлений, то матрицы, соответствующие операторам этого П. г., имеют квазидиагональный вид

$$T(g) = \begin{pmatrix} T_1(g) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & T_2(g) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & T_k(g) \end{pmatrix}$$

Если П. г. $D(G, V)$ не содержит нетривиальных подпредставлений, то оно наз. неприводимым. Реализуя алгебраич. неприводимость, т. е. отсутствие инвариантных подпространств, и топологич. неприводимость, при к-рой пространству П. г. не должно содержать замкнутых инвариантных подпространств. Алгебраически неприводимое П. г. является топологически неприводимым; обратное, вообще говоря, неверно. Полноту системы неприводимых П. г. устанавливают при помощи характеров П. г. $\chi(g)$. Для матричного П. г. $\chi(g) = \text{Tr} T(g)$.

Пусть на пространствах V_1 и V_2 задана невырожденная билинейная форма f и пусть V_2 — пространство П. г. $D(G, V_2)$. Всякому оператору $T(g)$ этого П. г. можно сопоставить дуальный оператор $T^*(g)$, действующий на пространстве V_1 так, что $f(T^*(g)v_1, v_2) = f(v_1, T(g)v_2)$. Если вместо оператора $T^*(g)$ рассмотреть оператор $T^{(*)}(g) = T^*(g^{-1})$, то множество операторов $T^{(*)}(g)$ образует П. г., называемое сопряжённым к $D(G, V_2)$ относительно формы f . Поскольку f невырождена, размерности П. г. $D(G, V_2)$ и $D^{(*)}(G, V_1)$ совпадают. Для конечномерных П. г. матрицы операторов $T^{(*)}(g)$ имеют вид $T^{(*)}(g) = (T^*)^{-1} \cdot T(g^{-1})$, где T^* — матрица формы f , а штрих означает транспонирование. Если рассмотреть П. г. $D(G, \mathcal{H})$ в гильбертовом пространстве \mathcal{H} и взять в качестве формы f скалярное произ-

вещные, то множество операторов $T^{(*)}(g) = (T^*(g))^{-1}$ ($*$ — эрмитово сопряжение) образуют П. г. $D^*(G, \mathcal{K})$, k -рое наз. «сопряженным к $D(G, \mathcal{K})$ ». Пусть теперь все операторы П. г. $D(G, \mathcal{K})$ унитарны. Тогда $D^*(G, \mathcal{K})$ будет совпадать с $D(G, \mathcal{K})$, и скалярное произведение инвариантно относительно D , т. е. для любых h_1, h_2 на \mathcal{K} и любого $T(g) : (T(g)h_1, T(g)h_2) = (h_1, h_2)$. Такое П. г. наз. унитарным. Всякое П. г., сохраняющее невырожденную билинейную форму, вполне приводимо, в частности вполне приводимо всякое конечномерное унитарное П. г.

П. г. $D(G, V)$ наз. циклическим, если существует вектор $v \in V$ из замкнутого линейной оболочки $D(G, V)$, такой, что $\{T(g)v\}$ образует базис для всех $T(g)$, совпадающей с V . Каждое унитарное П. г. является прямой суммой циклич. подпредставлений. Унитарное П. г. $D(G, \mathcal{K})$ неприводимо тогда и только тогда, когда каждый ненулевой вектор $h \in \mathcal{K}$ циклический для $D(G, \mathcal{K})$.

В приложениях приходится оперировать такими П. г., для k -рых процесс выделения инвариантных подпространств бесконечен. В этом случае используют обобщение понятия прямой суммы П. г. — прямой интеграл представлений.

Пусть $d\mu(g)$ — право(лево)инвариантная мера Хаара для локально компактной группы G (см. Инвариантное интегрирование). Рассмотрим пространство L^2 числовых (вещественных или комплексных) Φ -фнций $f(g)$, интегрируемых с квадратом по этой мере. Обозначим $T^R(g)$, $T^L(g)$ операторы преобразования в L^2 , порожденные правым (левым) сдвигом на элемент: $T^R(g)f(g') = f(g'g)$, $T^L(g)f(g') = f(g'g^{-1})$. Группа операторов $T^R(g)$, $T^L(g)$ образует линейное П. г. G в пространстве L^2 , k -рое наз. правым (левым), d -р. г. л. и р. м. П. г. Сдвиги пространства L^2 скалярным произведением $(f_1, f_2) = \int f_1(g)f_2(g)d\mu(g)$, где черта означает комплексное сопряжение, можно показывать, что регулярные представления унитарны.

При выделении неприводимых представлений некомпактных (локально компактных) групп весьма эффективной оказывается теория индуцированных П. г. Индуцированное П. г. $D(K, V) \uparrow G$ локально компактной группы G специальным образом конструируется из представления $D(K, V)$ замкнутой подгруппы $K \in G$. Пусть ϕ — Φ -фнция, отображающая G в V и удовлетворяющая условию: $\phi(kg) = T(k)\phi(g)$ для любых $g \in G, k \in K$, $T(k)$ — оператор П. г. $D(K, V)$. Тогда индуцированное представление $U(G, \mathcal{K}) = D(K, V) \uparrow G$ определяется в пространстве \mathcal{K} всех таких Φ -фнций $f(g)$ ($U(g)\phi(g') = \phi(g'g)$). Метод индуцированных представлений является простейшим приемом построения представлений более сложных групп из представлений более простых групп.

В квантовой механике используют т. н. проективные П. г., когда каждому элементу g ставится в соответствие оператор $T(g)$, действующий в пространстве V , причём для любых g_1 и g_2 из G : $T(g_1)T(g_2) = \omega(g_1, g_2)T(g_1g_2)$, где фазовый множитель $\omega(g_1, g_2)$ — числовая Φ -фнция, зависящая от g_1 и g_2 , а $T(e)$ — по-прежнему единичный оператор в V . На проективные П. г. непосредственно переносится понятия эквивалентности и неприводимости П. г.

Пусть $D_1(G, V_1)$ и $D_2(G, V_2)$ — два конечномерных П. г. G , имеющие размерности n_1 и n_2 . П. г. D наз. прямым (тензорным) произведением n_1 и n_2 П. г. D_1 и D_2 , $D = D_1 \otimes D_2$, оно имеет размерность $n_1 n_2$, а каждый его элемент представляет собой матрицу $n_1 n_2 \times n_1 n_2$, являющуюся прямым (криверным) произведением матрицы из $D_1(G, V_1)$, на матрицу из $D_2(G, V_2)$ (см. Матрица). Прямое произведение $D_1 \otimes D_2$ двух неприводимых конечномерных представлений D_1 и D_2 группы G неприводимо, если размерность пред-

ставления D_1 (или D_2) равна 1, в общем случае $D_1 \otimes D_2$ вполне приводимо.

Напр., в квантовых системах с группой симметрии G состоят Φ -фнц гамiltonиана можно классифицировать по неприводимым П. г. G . Теория П. г. позволяет в этом случае установить т. н. правила отбора при рассмотрении процессов перехода из одного состояния в другое. Если процесс перехода задается оператором O_α , соответствующим неприводимому П. г. $D_\alpha(G, V_\alpha)$, то переход из k -рого состояния ψ_k , соответствующего неприводимому П. г. $D_k(G, V_k)$, может осуществляться лишь в те конечные состояния ψ_l , представленные k -рых D_k содержится в разложении прямого произведения $D_\alpha \otimes D_k = \sum m_l D_l$.

Матричные элементы оператора C , приводящего прямое произведение $D_1 \otimes D_2$ к блочподдиагональному виду [т. е. $C(D_1 \otimes D_2)C^{-1} = \sum m_l D_l$, где D_l — не-

приводимое представление, m_l — его кратность в прямом произведении], наз. коэффициентами Клебша — Гордана. Неприводимое П. г. G , являющееся прямым произведением групп G_1 и G_2 (см. Группа), есть прямое произведение их неприводимых представлений, т. е. $D(G_1 \otimes G_2, V) = D_1(G_1, V_1) \otimes D_2(G_2, V_2)$.

Представления некоторых групп. Коммутативные и негруппы. Любое неприводимое унитарное представление локально компактной коммутативной группы одномерно, при этом каждому элементу группы ставится в соответствие комплексное число $\chi(g)$. Любое представление коммутативной группы ограниченных операторами в гильбертовом пространстве является суммой дискретной, если группа компактна) одномерных представлений.

Одним из наиб. завершённых разделов общей теории П. г. является теория представлений компактных групп, к-рым относятся все конечные группы, группы вращений плоскости и пространства, группы $SU(N)$ при различных N , рассматриваемые в теории элементарных частиц (см. Кабирировые поля, Унитарная симметрия), и т. д. Если группа компактна, то любому её представлению можно сопоставить эквивалентное ему унитарное представление, т. е. изучение представлений компактной группы сводится к изучению её унитарных представлений. Свойства унитарного представления полностью определяются свойствами его неприводимых компонент. Всякое неприводимое унитарное представление компактной группы конечномерно.

Если $D_1(G, \mathcal{K}_1)$ и $D_2(G, \mathcal{K}_2)$ — любые два неприводимых унитарных представления компактной группы G , то матричные элементы операторов этих представлений $T_{ik}^{(1)}(g)$ и $T_{lm}^{(2)}(g)$ удовлетворяют соотношениям

$$\int_G T_{ik}^{(1)}(g) \overline{T_{lm}^{(2)}(g)} d\mu(g) = \begin{cases} 0, & \text{если } D_1 \text{ и } D_2 \text{ не эквивалентны,} \\ \delta_{il} \delta_{km} / d_1, & \text{если } D_1 \sim D_2, \end{cases}$$

где $d_1 = \dim D_1$; черта означает комплексное сопряжение. Считается, что базисы в пространствах \mathcal{K}_1 и \mathcal{K}_2 ортонормированы.

Пусть $\{D^k(G)\}$ — система всех неэквивалентных неприводимых унитарных представлений компактной группы G . Фнции $d_i^k / T_{ik}^{(k)}(g)$ ($i, k = 1, \dots, d_k$), где $d_k = \dim D^k$, образуют полный ортонормированный базис в пространстве L^2 (теорема Петера — Вейля).

Всякое неприводимое унитарное представление компактной группы эквивалентно подпредставлению её прямого регулярного представления $D^R(G)$.

Представления конечных групп. Каждая конечная группа компактна. Поэтому утверждения, касающиеся представлений компактных групп, справедливы и для конечных групп, только во всех \mathfrak{g} -флах необходимо заменить интегрирование по группе $\int d\mu(g)$ суммированием по групповым элементам

$$\int d\mu(g) \rightarrow |G|^{-1} \sum_{g \in G} \text{ где } |G| \text{ — порядок конечной группы.}$$

Конечная группа имеет конечное число неприводимых П. г. Сумма квадратов размерностей всех неприводимых неэквивалентных П. г. равна порядку группы (теорема Бёрнсайда), причём все эти размерности являются делителями порядка группы. Число различных неприводимых представлений конечной группы равно числу классов сопряжённых элементов.

Представления групп Ли. Оператор $T(g)$ представления $D(G, V)$ n -мерной группы Ли, так же как и соответствующий элемент группы Ли, зависит от параметров a_1, \dots, a_n , т. е. $T(g(a)) = T(a_1, \dots, a_n) \equiv T(a)$. Для т. г. дифференцируемых П. г. функция $T(a)$ дифференцируема (так, в частности, будет, если представление $D(G, V)$ конечномерно), можно ввести набор операторов $\partial_i(X_i) = \partial T(a)/\partial a_i$, $i = 1, \dots, n$, наз. г. г. е. н. о. р. а. т. о. р. а. м. представления $D(G, V)$; здесь X_i — генераторы группы. В первом приближении по a_i получим $T(a) \approx I + \sum_{i=1}^n a_i t(X_i)$. Операторы $t(X_i)$ ($i = 1, \dots, n$) образуют базис Ли алгебры, к-рая наз. л. и. д. ф. р. е. н. ц. и. а. л. Дифференциал П. г. в свою очередь является представлением алгебры Ли соответствующей группы.

Пусть $g(a)$ — элемент однопараметрич. подгруппы группы G . Связь между П. г. $D(G, V)$ и его дифференциалом [представлением соответствующей алгебры Ли $\mathfrak{d}(A, V)$] дается ф-лой $t(X) = dT(g(a))/da$. Если θ — связанная группа Ли, то её конечномерные представления полностью определяются своими дифференциалами. Напр., если $D(G, V)$ — конечномерное П. г. G , а $d(A, V)$ — представление алгебры Ли A этой группы, являющееся дифференциалом D , то всякое подпространство пространства V , инвариантное относительно D , инвариантно также относительно d . П. г. D и d неприводимы, приводимы и вполне приводимы одновременно. Если $D_1(G, V_1)$ и $D_2(G, V_2)$ — представления связанной группы Ли G , а $d_1(A, V_1)$ и $d_2(A, V_2)$ — их дифференциалы, то их эквивалентности $d_1 \sim d_2$ следует эквивалентность $D_1 \sim D_2$ и наоборот. Конечномерные представления связанных односвязных групп Ли находятся во взаимно однозначном соответствии с представлениями их алгебр Ли. Эти представления связаны ф-лой $T(g(a)) = \exp(at(X))$. Для унитарных представлений в гильбертовых пространствах из эквивалентности дифференциалов следует эквивалентность П. г.

Поэтому удобен т. н. и. в. ф. и. н. и. т. з. м. а. л. и. й т. о. д. х. д., когда исследование П. г. сводят к исследованию представлений их алгебр. Каждому элементу Y из алгебры Ли A группы Ли G ставится в соответствие оператор $\text{ad}(Y) = [Y, X]$, для любого X из A . Т. к. из тождества Якоби следует, что $\text{ad}([Y, X]) = [\text{ad}(Y), \text{ad}(X)]$, то операторы $\text{ad}(Y)$ образуют представление алгебры A . Это представление наз. п. р. и. с. о. е. д. и. н. ы. м. п. р. е. д. с. т. а. в. л. е. н. и. е. м. алгебры Ли. Если X_1, \dots, X_n — базис алгебры A , то матричные элементы операторов $\text{ad}(X_i)$ в этом базисе совпадают со структурными константами алгебры Ли: $(\text{ad}(X_i))_j^k = C_{ij}^k$.

Если A — алгебра Ли связанной группы G , то представление алгебры ad можно продолжить до представ-

ления группы G , действующего в A , как в векторном пространстве. При соединении n представлений n групп G наз. такое отображение $\text{Ad}(g, A)$, что $\exp(\text{Ad}(g)X) = g \exp X g^{-1}$. Для любых $X \in A$ и $g \in G$. Размерность присоединённого П. г. совпадает с размерностью группы Ли.

В рамках инфинитезимального подхода развиты теория конечномерных представлений полупростых групп Ли, имеющая важное значение для теории элементарных частиц. Всякое конечномерное представление полупростой алгебры вполне приводимо. Поэтому исследование конечномерных представлений полупростых алгебр сводится к исследованию неприводимых конечномерных представлений.

Для классификации неприводимых конечномерных представлений комплексных алгебр Ли используют т. н. теорию старших весов. Пусть эрмитовы операторы H_i , $i = 1, \dots, r$; r — размерность группы Ли G — базисные элементы подалгебры Картана. Рассмотрим комплексное конечномерное представление $d(A, V)$ алгебры Ли A группы G . Тогда операторы $t(H_i) \in d(A, V)$ эрмитовы, они коммутируют друг с другом и поэтому имеют общие собств. векторы $\psi_m \in V$, т. е. такие, что $t(H_i)\psi_m = m_i \psi_m$ ($i = 1, \dots, r$); m — r -мерный векств. вектор $m = (m_1, \dots, m_r)$, соответствующий ψ_m , называется весом ψ_m в $d(A, V)$.

Обозначим через W множество всех элементов g полупростой группы Ли G , обладающих тем свойством, что $gKg^{-1} = K$, где K — подгруппа Картана группы G (K — группа, алгеброй к-рой является подалгебра Картана). Множество W является подгруппой G , причём $K \in W$ и является нормальным делителем W . Факторгруппа W/K наз. группой отражений Вейля. Эта группа конечна.

Два веса m и m' наз. эквивалентными, если они связаны друг с другом группой отражений Вейля. Число разл. весов не превышает размерности представления. Говорят, что вес m старше веса m' , если вектор $m - m'$ положительн, т. е. его первая отличная от нуля компонента положительна. Старший вес из множества эквивалентных весов наз. доминантным. Вес, к-рый старше всех остальных весов представления, наз. старшим весом представления.

Неприводимое конечномерное представление полупростой алгебры Ли полностью определяется своим старшим весом (теорема Картана). Для каждой простой алгебры Ли с r -мерной подалгеброй Картана имеется r фундаментальных весов $M^{(i)}$ ($i = 1, \dots, r$), называемых фундаментальными, таких, что остальные доминантные веса можно представить в виде $M = \sum_{i=1}^r \lambda_i M^{(i)} = M(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$, где $\{\lambda_i\}$ — набор неотрицат. целых чисел. Существует г. т. в. фундаментальных неприводимых конечномерных представлений простой алгебры, к-рые имеют r фундаментальных доминантных весов в качестве своих старших весов. Соответствующие П. г. наз. фундаментальными.

До сих пор речь шла об односвязных П. г., когда каждому элементу группы G ставится в соответствие только один оператор $T(g)$. Если группа G не является односвязной, то для того, чтобы П. г. было непрерывным, возникает необходимость каждому элементу группы g ставить одновременно в соответствие неск. разл. операторов $T_1(g), T_2(g), \dots, T_m(g)$. Такое П. г. наз. m -значным.

Лит.: Вилленки П. Я., Специальные функции и теория представлений групп, М., 1965; Жейлоб в е н к о Д. П., Компактные группы Ли и их представления, М., 1970; Киррилово А. А., Элементы теории представлений, 2-е изд., М., 1978; Наймарк М. А., Теория представлений групп, М., 1978; Менский М. В., Метод инвариантных представлений. Пространство — время и квантовая частота, М., 1978; Климык А. У., Матричные элементы и коэффициенты Якоби — Гордана представлений групп, К., 1978; Барут А.,

Ромкина Р., Теория представлений групп и ее приложения, т. 1—2, пер. с англ., М., 1980; см. также лит. при ст. Гуревича.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИЯ в квантовой механике — изучает схемы конкретных реализаций квантовых наблюдаемых как самосопряженных операторов, действующих в гильбертовом пространстве, и состояний как векторов этого пространства.

Традиц. построение аппарата *квантовой механики*, восходящее к П. А. М. Дираку (P. A. M. Dirac), состоит в обобщении введенного В. Гейзенбергом (W. Heisenberg), М. Борном (M. Born) и П. Йорданом (P. Jordan) матричного описания физ. величин в абстрактную алгебраич. схему q -чисел, в k -рой операции дифференцирования по динамики, переменным классич. механики заменяются образованием коммутаторов с канонически сопряженными переменными. Для практич. вычислений нужно реализовать элементы этой алгебры операторами в гильбертовом пространстве — пространстве состояний. При этом элементам, имеющим физ. смысл, — квантовым наблюдаемым — должны отвечать самосопряженные операторы, из собств. векторов k -рых можно набрать в пространстве состояний полную систему U . Коммутирующие операторы, относящиеся к одновременно измеряемым a_i (см. *Неопределенностей соотношения*), обладают общей системой собств. векторов. Совокупность n независимых коммутирующих операторов A_i наз. в од. и в об. о-ром, если любой оператор, коммутирующий со всеми A_i , является их ф-цией.

Пусть $\varphi_{a_1}, \dots, \varphi_{a_n}$ — общая полная система собств. векторов такого набора:

$$A_i \varphi_{a_1, \dots, a_n} = a_i \varphi_{a_1, \dots, a_n}$$

Тогда любой вектор ψ на пространстве состояний \mathcal{H} может быть разложен по базису $\varphi_{a_1, \dots, a_n}$:

$$\psi = \sum_{(a)} \psi(a_1, \dots, a_n) \varphi_{a_1, \dots, a_n}$$

(суммирование проводится по всем собств. значениям $(a) = a_1, a_2, \dots, a_n$), где $\psi(a_1, \dots, a_n)$ наз. в од. и в об. о-рой ф-цией в (A_i) -представлении:

$$\psi(a_1, \dots, a_n) = \langle \psi, \varphi_{a_1, \dots, a_n} \rangle,$$

причем скалярное произведение (\dots, \dots) в \mathcal{H} определено ф-лой

$$\langle \psi_1, \psi_2 \rangle = \sum_{(a)} \psi_1(a_1, \dots, a_n) \psi_2^*(a_1, \dots, a_n).$$

Действие A_i сводится в (A_i) -представлении к умножению на число:

$$A_i \psi(a_1, \dots, a_n) = a_i \psi(a_1, \dots, a_n),$$

а для любого другого самосопряженного оператора C выражается через матричные элементы

$$c_{(a), (a')} = \langle \varphi_{a_1, \dots, a_n}, C \varphi_{a'_1, \dots, a'_n} \rangle$$

в выбранном базисе:

$$C \psi(a_1, \dots, a_n) = \sum_{(a')} c_{(a), (a')} \psi(a'_1, \dots, a'_n).$$

Из существования разл. полных наборов коммутирующих операторов вытекает возможность разл. представлений. Переход от одного представления к другому сводится к замене базиса в \mathcal{H} :

$$\varphi(a) \rightarrow \varphi(b) = \sum_{(a')} U(b, (a')) \varphi(a').$$

При этом волновая ф-ция в (B_k) -представлении

$$\psi(b_1, \dots, b_n) = \langle \psi, \varphi(b) \rangle = \sum_{(a)} U(b, (a)) \psi(a_1, \dots, a_n),$$

или

$$\psi \rightarrow U \psi,$$

связана с $\varphi(a_1, \dots, a_n)$ унитарным преобразованием: из свойств ортонормированности базисов вытекает

$$\sum_{(a)} U(b, (a)) U^*(a', (b')) = \delta(b, (b')),$$

или

$$U U^* = 1.$$

Матричные элементы операторов преобразуются при этом по ф-ле

$$c_{(b), (b')} = \sum_{(a), (a')} U(b, (a)) c_{(a), (a')} U^*(a'), (b')),$$

или

$$C \rightarrow U C U^{-1}.$$

Благодаря унитарности преобразования старая и новая системы матричных элементов и волновых ф-ций физически эквивалентны: спектры операторов, ср. значения и вероятности переходов совпадают.

Унитарные преобразования являются квантовым аналогом классич. канонич. преобразований. Эта аналогия не сводится, однако, к взаимно однозначному соответствию. С одной стороны, согласно принципу неопределенности, точные значения в данном представлении может принимать только половина квантовых наблюдаемых, причём имеется значит. провалов в выборе этой половины. Поэтому число квантовых представлений значительно больше числа операторов классич. канонич. переменных. С др. стороны, не все наборы классич. канонич. переменных имеют квантовый аналог. Простейшим примером служат переменные действие — угол: в отличие от действия, квантовый аналог угла не существует как самосопряженный оператор.

Описанная выше «идеальная» схема реализуется лишь в простейшем случае операторов с чисто точечным спектром. В действительности уже такие естеств. квантовые наблюдаемые, как координаты и импульсы, имеют непрерывный спектр и представлены неогранич. операторами. Собств. ф-ция неогранич. операторов не принадлежит гильбертову пространству и оказываются *обобщенными функциями*. Сама эти операторы хорошо определены не на всем \mathcal{H} , а лишь на его плотн. подмножестве, на k -ром указаны обобщенные ф-ция являются линейными функционалами. При этом проблема квантования ставится как задача конструирования представлений канонических *перестановочных соотношений* в \mathcal{H} .

В простом, но нетривиальном примере бесструктурной частицы независимыми наблюдаемыми служат координаты Q_i и импульсы P_i ($i = 1, 2, 3$), подчиняющиеся перестановочным соотношениям Гейзенберга:

$$[Q_i, Q_j] = [P_i, P_j] = 0, \quad [Q_i, P_k] = i \hbar \delta_{ik}.$$

В координатном представлении в качестве полного набора коммутирующих операторов выбираются Q_i . Пространством состояний служит пространство $L^2(\mathbb{R}^3)$ квадратично интегрируемых комплекснозначных ф-ций $\psi(x)$, $x = x_1, x_2, x_3$, со скалярным произведением

$$\langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \varphi_1(x) \varphi_2^*(x) dx.$$

Действие операторов Q_1 , P_1 задается ф-лами

$$Q_1\varphi(x) = x_1\varphi(x), \quad P_1\varphi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_1} \varphi(x)$$

и, вообще говоря, выводит ф-ции из L^2 . Хорошо определены эти операторы на множестве D бесконечно дифференцируемых ф-ций, убывающих на бесконечности быстрее любой степени: действие Q_1 , P_1 и любых их нелых положит. степеней не выводит из D . В Д легко проверяется самосопряженность операторов и неприводимость их представления (т. е. что любой коммутирующий с Q_1 и P_1 оператор кратен единичному).

Общая полная система собств. ф-ций операторов Q_1 (с собств. значениями x^0) имеет вид

$$\varphi_{x^0}(x) = \delta(x - x^0) = \delta(x_1 - x_1^0) \delta(x_2 - x_2^0) \delta(x_3 - x_3^0),$$

где $\delta(x)$ — введенная для описания непрерывного спектра δ -функция Дирака. В этом примере легко находится и соответствующая система собств. ф-ций операторов P_1 :

$$\varphi_{p^1}(x) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \exp(ip^1 x/\hbar).$$

Хотя первая система — обобщенные, а вторая — обычные ф-ции, обе они не принадлежат L^2 , т. е. не квадратично интегрируемы.

Тому же выбору классич. канонич. переменных отдают и импульсное представление, в котором полным набором коммутирующих наблюдаемых служат операторы P_1 . Элементы \mathcal{X} являются теперь ф-ции $\tilde{\varphi}(p)$ на $L^2(\mathbb{R}^3)$, действие операторов задано ф-лами

$$Q_1\tilde{\varphi}(p) = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_1} \tilde{\varphi}(p), \quad P_1\tilde{\varphi}(p) = p_1\tilde{\varphi}(p),$$

а их собств. ф-ции имеют вид

$$\tilde{\varphi}_{x^0}(p) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \exp(ipx^0/\hbar), \quad \varphi_{p^1}(p) = \delta(p - p^0),$$

т. е. опять не принадлежат L^2 .

Ф-ции $\tilde{\varphi}(p)$ связаны с $\varphi(x)$ преобразованием Фурье

$$\tilde{\varphi}(p) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int_{\mathbb{R}^3} \exp(-ipx/\hbar) \varphi(x) dx = U\varphi(x),$$

т. е. выглядят как действие на $\varphi(x)$ интегрального оператора U ; обратное преобразование получается действием сопряженного оператора: $\varphi(x) = U^*\tilde{\varphi}(p)$. Благодаря равенству Парсеваля

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\varphi(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^3} |\tilde{\varphi}(p)|^2 dp$$

этот оператор унитарен, т. е. координатные и импульсные представления унитарно эквивалентны.

Унитарная эквивалентность характерна для любой квантовой механики, системы с конечным числом степеней свободы: по теореме фон Неймана — Стоуна неприводимое представление канонич. перестановочных соотношений единственно с точностью до унитарного преобразования. Выбор представления диктуется соображениями удобства и простоты в конкретной физ. ситуации. Помимо координатного и импульсного представлений наиб. употребительны: представление, где полным набором операторов служат операторы Гамильтона H , квадрата момента M^2 и его проекция на ось z (в задачах о частоте в центр. поле); *Фокса представления* (в задачах, где система трактуется как набор слабо взаимодействующих осцилляторов); голоморфное представление (в описании когерентных оптич. пучков и аналогичных систем) и т. д.

Для систем с бесконечным числом степеней свободы теорема фон Неймана — Стоуна неприменима, и существ-

ует бесконечное множество унитарно эквивалентных представлений канонич. перестановочных соотношений. Необходимость рассмотрения таких бесконечномерных систем объясняется двумя обстоятельствами: для канонич. теории поля — реальностью этих систем, *полной физический*; для статистич. физики — отсутствием гуретич. методов описания релаксации к равновесному состоянию для конечномерных систем, отсутствия фазовых переходов в таких системах. Соответствующие матем. оформление весьма сложно и с необходимостью использует нефокусные представления перестановочных соотношений. К-л. законченной схемы, позволяющей описать реальные физ. системы строго, пока нет, хотя рассмотрены мн. примеры, моделирующие ту или иную сторону реальной ситуации. Большинство же прикладных (с точки зрения П. т.) задач *используют возмущенную теорию, основанную на фокусном представлении канонич. перестановочных соотношений.*

Лит.: Дирак П. А. М., Принципы квантовой механики, пер. с англ., 2-е изд., М., 1979; Фридрихс К. О., Вмещающие спектра операторов в гильбертовом пространстве, пер. с англ., М., 1969; Вильд Н., Статистическая механика, пер. с англ., М., 1971; Завьялов О. И., Сушко В. Н., Неквантовые представления соотношений коммутации в физике бесконечных систем, в сб.: Статистическая физика и квантовая теория поля, М., 1973; М. и др. в сб.: В. В. Иванов, Теоретическая физика, М., 1977; Фаддеев Л. Д., Якубовский Я. О. А., Лекции по квантовой механике для студентов-математиков, Л., 1980. В. В. Мейеров, В. П. Долово.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ (красота) (англ. beauty) — квантовое число, характеризующее порядок, тип (*аромат*) кванта (*b*-кварка), а также адроны, в состав к-рых входит *b*-кварк (антикварк \bar{b}). См. *Красота*.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВОЛН (рефракция волн) — изменение направления распространения волн в неоднородной среде, обусловленное зависимостью фазовой скорости волн от координат. П. в. может рассматриваться как отдельное (независимое от дифракции волн) явление только в рамках применения лучевой описания волновых процессов (см. *Геометрическая оптика*, *Геометрическая акустика*). Соответственно различают П. в. на плоской или плавно изогнутой (в масштабе длин волн) границе раздела однородных сред и П. в. в плавно неоднородной (в масштабе длин волн) среде (интерд. термин «рефракция» относят только к этому случаю).

При преломлении плоской, монохроматич. волны на плоской границе раздела двух однородных непоглощающих сред направления распространения падающей и преломленной волн связаны соотношением $\sin\theta_1/\sin\theta_2 = v_2/v_1$ (*Снелла закон преломления*), где θ_1 , θ_2 — углы падения и преломления, т. е. углы между нормальными фазовых скоростей v_1 , v_2 и нормалью к границе. В изотропных средах величина $n = v_2/v_1$ не зависит от угла падения и наз. относн. показателем преломления двух сред; для эл.-магн. волн вводит абс. показатель преломления как отношение скорости света в вакууме к фазовой скорости в среде. При $(v_2/v_1)\sin\theta_1 > 1$ не существует действит. углов θ_2 , удовлетворяющих закону П. в., и преломленная волна отсутствует — явление полного внутреннего отражения. Однако и в этом случае закон П. в. формально выполняется при комплексных значениях угла преломления, к-рым соответствует бегущие вдоль границы и экспоненциально спадающие при удалении от нее моды. На границе раздела изотропных сред, в к-рых величина фазовой скорости зависит от направления распространения, одной падающей могут соответствовать неск. преломленных волн, групповые скорости к-рых направлены от границы в глубь среды (угол преломления при этом может быть тупым). П. в. на режках границах раздела едт сопрягается (за редким исключением) отражением волн. Соотношение амплитуд падающей, преломленной и отраженных волн зависит от природы и «поляризации» волн и в эл.-магн. случае определяется *Френеля формулами*. На эффекте П. в. основан принцип действия большинства оптич. устройств (микроскопов, телескопов, спектрографов, фотоаппаратов, световодов и др.). Рефракция объясняется мн. явлениями природы: миражи, звуковые

каналам в ионосфере атмосферы, сверхдальняя радиосвязь и др.

Лит.: Брежневский Л. М., Волны в слоистых средах, 2 изд., М., 1973; Фейнман Р., Дайтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, пер. с англ., 3 изд., т. 3, М.: Мир, 1978; М. А. Миллер, Г. В. Перышкин. ПРЕЛОМЛЕНИЕ РАДИОВОЛН — см. Рефракция радиоволн.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА — изменение направления распространения световой волны (светового луча) при прохождении через границу раздела двух различных прозрачных сред. На плоской границе раздела двух однородных изотропных сред с абс. преломления показателями n_1 и n_2 П. с. определяется след. законами: падающий, отраженный и преломленный лучи и нормаль к границе раздела в точке падения лежат в одной плоскости (плоскости падения); угол падения φ_1 и преломления φ_2 (рис. 1), образованные соответствующими лучами с нормалью, и показатели преломления сред n_1 и n_2 связаны для монохроматич. света *Синусом законом*

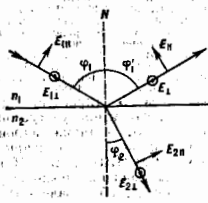


Рис. 1. Преломление света на границе раздела двух сред с показателями преломления n_1 и n_2 ($n_1 < n_2$); стрелками показано направление вектора в плоскости падения, кружками — перпендикулярно плоскости падения.

преломления $n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$. Обычно П. с. сопровождается отражением света от той же границы. Для непроводящих (прозрачных) сред полная энергия светового потока преломленной волны равна разности энергий потоков падающей и отраженной волн (закон сохранения энергии). Отношение интенсивностей светового потока преломленной волны K падающей — коэф. пропускания границы раздела сред τ_{11} — зависит от поляризации света падающей волны, угла падения φ_1 и показателя преломления n_1 и n_2 . Строгое определение интенсивности преломленной (и отраженной) волны может быть получено из решения у-ий Максвелла с соответствующими граничными условиями для электрич. и магн. векторов световой волны и выражается *Формулой Френеля*. Если электрич. вектор падающей и преломленной волн разложить на две компоненты E_{11} (лежащую в плоскости падения) и E_{12} (перпендикулярную к ней), φ -лы Френеля для коэф. пропускания соответствующих компонент имеют вид

$$\tau_{11} = \frac{E_{11}^2}{E_{11}^2} = \frac{\sin 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2}{\sin^2(\varphi_1 + \varphi_2) \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\tau_{12} = \frac{E_{12}^2}{E_{12}^2} = \frac{\sin 2\varphi_1 \sin 2\varphi_2}{\sin^2(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

Зависимость величин τ_{11} и τ_{12} от φ_1 приведена на рис. 2. Из выражений (*) и рис. 2 следует, что для всех углов падения $\tau_{11} \geq \tau_{12}$, кроме частного случая нормальной падения ($\varphi_1 = \varphi_2 = 0$), когда

$$\tau_{11} = \tau_{12} = 4n_1 n_2 / (n_1 + n_2)^2$$

Это означает, что для всех φ_1 (кроме $\varphi_1 = 0$) происходит поляризация преломленного света. Если на границу раздела падает естественный (не поляризованный) свет, для k -го $E_{11}^2 = E_{12}^2$, то в преломленной волне $E_{11}^2 > E_{12}^2$, т. е. свет будет частично поляризованным. Напр., значит, поляризация преломленной волны про-

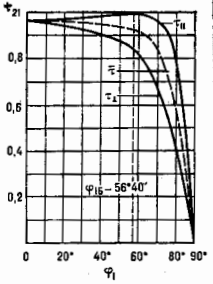


Рис. 2. Зависимость коэффициентов пропускания τ_{11} , τ_{12} и $\tau_{11} = 1/2(\tau_{11} + \tau_{12})$ для волн равной поляризации от угла падения φ_1 при преломлении на границе воздух ($n_1 = 1$) — стекло (с показателем преломления $n_2 = 1,52$); τ_{11} — для падающей неполяризованной света.

исходит при падении под углом Брюстера $\varphi_{1B} = \text{arctg}(n_2/n_1)$, когда $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$ (рис. 2). При этом $\tau_{11} < 1$, а $\tau_{12} = 1$, т. е. преломление поляризов. света с E_{12} не сопровождается отражением.

Если свет падает из среды оптически менее плотной в более плотную ($n_2 > n_1$), то $\varphi_2 < \varphi_1$ и преломленный луч существует при всех значениях угла φ_1 от 0 до 90°. Если свет падает из среды оптически более плотной в менее плотную ($n_2 < n_1$), то $\varphi_2 > \varphi_1$ и преломленная волна существует лишь в пределах угла падения от $\varphi_1 = 0$ до $\varphi_1 = \text{arcsin}(n_2/n_1)$. При углах падения $\varphi_1 > \text{arcsin}(n_2/n_1)$ П. с. не происходит, существует только отраженная волна — явление *полного внутреннего отражения*.

В оптических анизотропных средах в общем случае образуются две преломленные световые волны с взаимно перпендикулярной поляризацией (см. *Кристаллооптика*).

Формально законы П. с. для прозрачных сред могут быть распространены и на поглощающие среды, если рассматривать показатель преломления для таких сред как комплексную величину $n_{\text{пог}} = n(1 - ik)$, где k — показатель поглощения. В случае металлов, обладающих сильным поглощением (и большим коэф. отражения), идущая внутрь металла волна поглощается в тонком приповерхностном слое и понятие преломленной волны теряет смысл (см. *Металлооптика*).

Поскольку показатель преломления сред зависит от длины волны света λ (см. *Дисперсия света*), то в случае падения на границу раздела прозрачных сред непохож. света преломленные лучи разл. для волн идут по разл. направлениям $\varphi_2 = \varphi_2(\lambda)$, что используется в дисперсионных призмах.

На П. с. на выгнутых, вогнутых и плоских поверхностях прозрачных сред основано действие линз, служащих для получения *изображений оптических*, дисперсионных призм и др. оптич. элементов.

Если показатель преломления меняется непрерывно (напр., в атмосфере с высотой), то при распространении светового луча в такой среде также происходит непрерывное изменение направления распространения — луч искривляется в сторону большего значения показателя преломления (см. *Рефракция света в атмосфере*), во при этом отражения света не происходит.

Под действием излучения большой интенсивности, создаваемого мощными лазерами, среда становится нелинейной. Индуцированные в молекулах среды под действием сильного электрич. поля световой волны диполи вследствие агармоничности колебаний электронов молекул излучают в среде вторичные волны не только на частоте ω падающего излучения, но также волны с удвоенной частотой — гармоники 2ω (и более высокие гармоники $3\omega, \dots$). С молекулярной точки зрения интерференция этих вторичных волн приводит к образованию в среде результирующих преломлен-

ных волн с частотой ω (как в линейной оптике) (см. Гюйгенса — Френеля принципа), а также с частотой 2ω , к-рым соответствуют макроскопич. показатели преломления $n(\omega)$ и $n(2\omega)$. Вследствие дисперсии среды $n(\omega) \neq n(2\omega)$ и, следовательно, в среде образуются две преломленные волны с частотами ω и 2ω , распространяющиеся по разл. направлениям. При этом интенсивность преломленной волны на частоте 2ω значительно меньше интенсивности на частоте ω (подробнее см. в ст. *Нелинейная оптика*).

Лит.: Ландсбергер Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Сидухин Д. В., Общий курс физики, 2 изд., т. 41 — Оптика, М., 1985.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ (преломления коэффициент) — оптич. характеристика среды, связанная с преломлением света на границе раздела двух прозрачных оптически однородных и изотропных сред при переходе его от одной среды в другую и обусловленная различием фазовых скоростей распространения света c_1 и c_2 в средах. Величина n п., равная отношению этих скоростей $n_0 = c_1/c_2$ нав. относительно n п. в этих средах. Если свет падает на вторую или первую среду из вакуума (где скорость распространения света c), то величина $n_0 = c/c_2$ п. $n = c/c_1$ нав. а б с о л т т а м и п. п. данных сред. При этом $n_2 = n_1/n_0$, n закон преломления может быть записан в виде $n_2 \sin \varphi_2 = n_1 \sin \varphi_1$, где φ_1 и φ_2 — углы падения и преломления.

Величина абсолютного n п. зависит от природы и строения вещества, его агрегатного состояния, температуры, давления и др. При больших интенсивностях n п. зависит от интенсивности света (см. *Нелинейная оптика*). У ряда веществ n п. изменяется под действием внеш. электрич. поля (*Керра эффект* — в жидкостях и газах; *Ванкелероутич. Показатель эффект* — в кристаллах).

Для данной среды n п. зависит от длины волны света λ , причём в области полного поглощения эта зависимость имеет аномальный характер (см. *Дисперсия света*). В рефр. области n п. практически для всех сред близок к 1; в видной области для жидкостей и твёрдых тел — порядка 1,5; в ИК-области для ряда прозрачных сред n п. до 4,0 (для Ge).

Анизотропные среды характеризуются двумя n п.: обыкновенным n_0 (аналогично изотропным средам) и n_e — необыкновенным, величина к-рого зависит от угла падения луча и, следовательно, направления распространения света в среде (см. *Кристаллооптика*). Для сред, обладающих поглощением (в частности, для металлов), n п. является комплексной величиной и может быть представлен в виде $n = n' + i(k)$, где n' — обычный n п., k — показатель поглощения (см. *Поглощение света, Металлооптика*).

n п. является макроскопич. характеристикой среды и связывается с её диэлектрической проницаемостью ϵ и магн. проницаемостью μ : $n = \sqrt{\epsilon\mu}$. Классич. электронная теория (см. *Дисперсия света*) позволяет связать величину n п. с микроскопич. характеристиками среды — электронной поляризуемостью атома (или молекулы) α , зависящей от природы атомов и частоты света, и плотностью среды: $n^2 = 1 + 4\pi N\alpha$, где N — число атомов в единице объёма. Действующее на атом (молекулу) электрич. поле E световой волны вызывает смещение оптич. электрона из положения равновесия; атом приобретает индукцию. дипольный момент $p = \alpha E$, являющийся во времени с частотой падающего света, и является источником вторичных когерентных волн, явн. интерферируя с падающей на среду волной, образуют результирующую световую волну, распространяющуюся в среде с фазовой скоростью $c_1 < c$, и поэтому $n = c/c_1 > 1$.

Интенсивность обычных (не лазерных) источников света относительно невелика, напряжённость электрич. поля E световой волны, действующего на атом, много меньше внутриатомных электрич. полей, и электрон в атоме можно рассматривать как гармонич. осцилля-

тор. В этом приближении величина α и n п. $n = \sqrt{1 + 4\pi N\alpha}$ являются величинами постоянными (на данной частоте), не зависящими от интенсивности света. В интенсивных световых потоках, создаваемых мощными лазерами, величина электрич. поля световой волны может быть соизмерима с внутриатомными электрич. полями и модель гармонич. осциллятора оказывается неприменимой. Учёт нелинейности сил в системе электрон — атом приводит к зависимости поляризуемости атома α , а следовательно и n п., от интенсивности света. Связь между α и E оказывается нелинейной; n п. может быть представлен в виде $n_0 + n_2 E^2 + n_4 E^4$, где n_0 — n п. при малых интенсивностях света; n_2 (обычно принятое обозначение) — нелинейная добавка к n п., или коэф. нелинейности. n п. n_2 зависит от природы среды, напр. для силикатных стёкол $n_2 = (1,4 \pm 1,5) \cdot 10^{-13}$ см²/В².

На n п. влияет высокая интенсивность ещё и в результате эффекта *электрострикции*, изменяющего плотность среды, высокочастотного эффекта Керра для анизотропных молекул (в жидкостях), а также в результате повышения темп-ры, вызванного поглощением излучения. Все эти эффекты прямо пропорциональны интенсивности света ($\sim E^2$) и дают вклад в величину n_2 .

n п. фоторефрактивных кристаллов (напр., LiNbO₃) также зависит от интенсивности света в результате возникновения и пространственного перераспределения в кристалле электрич. зарядов; причём изменение n п. сохраняется довольно долго и после прекращения засветки.

n п. как оптич. характеристика среды в линейной оптике часто используется при физ.-хим. анализах. n п. к. л. вещества обычно пропорционально по отношению к объёду для $\lambda = 589$ —589,6 нм (желтый дублет линии натрия), при $t = 20^\circ \text{C}$, атм. давления и обозначается n_D . Для твёрдых тел величина n_D изменяется в пределах от 1,3 до 4,0, для жидкостей — от 1,2 до 1,9, для газов (при нормальных условиях) — от 1,000035 (He) до 1,000702 (Xe), для воздуха $n_D = 1,00029$. Измерение n_D производится с помощью *рефрактометров*.

Лит.: Ландсбергер Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Сидухин Д. В., Общий курс физики, 2 изд., т. 41 — Оптика, М., 1985.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ — сдвиг спектра сигнала по частоте без изменения формы спектра. n ч. возникает при взаимодействии колебаний сигнала и гетеродина на нелинейном устройстве, наз. смесителем; в результате в спектре выходного сигнала наряду с др. частотами образуются равная и суммарная частоты; выделены одной из них и является результатом работы смесителя. Величина сдвига определяется частотой вспомогат. генератора (гетеродина).

n ч. используют в радиоприёмных устройствах, например, технике, эталонных генераторах и т. д., поскольку при этом усилении сигнала в широком диапазоне перестраиваемых частот заменяется усилением перестраиваемой комбинац. частоты, наз. пром. n ч. и n ч. о. н. й. Постоянство промежуточной частоты $\omega_n = \omega_c - \omega_s = \text{const}$ при перестройке частоты сигнала ω_c обеспечивается одноврем. перестройка частоты гетеродина ω_s . Т. о., усиление сигнала в устройствах с n ч. осуществляется на сравнительно низкой, обычно стандартной частоте.

При передаче информации радиочастотное колебание можно модулировать по разл. параметрам: амплитуде $E_c(t)$, частоте $\omega_c(t)$ и фазе $\varphi_c(t)$ (см. *Модулированные колебания*). Для того чтобы при n ч. модуляция была перенесена на промежуточную частоту без искажений, необходимо выполнение след. условий: 1) нелинейное устройство (напр., полупроводниковый диод) должно иметь вольт-амперную характеристику, близкую к квадратичной для аппроксимируемого полнымом четвёртой степени; 2) амплитуда сигнала E_c должна быть много меньше амплитуды колебаний гетеродина E_s ; 3) частота ω_c должна быть выше ω_n .

Поскольку в выходной цепи смесителя имеются разл. комбинац. частоты, то для выделения разностной или суммарной частоты выходная цепь должна быть избирательной, т. е. резонансной, настроенной на нужную частоту.

Под П.ч. часто понимают и др. операции, осуществляемые, напр., при помощи делителя частоты или умножителя частоты.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИММЕТРИИ — см. *Симметрия кристаллов*.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВСТРЕЧНО-ШТЯБЕВЫЕ (ВШП) — см. *Пьезоэлектрические преобразователи*.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ — устройство, вырабатывающее напряжение питания заданной величины из др. питающего напряжения (напр. для питания аппаратуры от аккумулятора). Одним из осн. требований, предъявляемых к П. и., является обеспечение максимального кпд.

Преобразование перем. напряжения легко осуществляется с помощью трансформатора, поэтому преобразователя пост. напряжения выделяются, как правило, на основе промежуточного преобразования перем. напряжения в переменное. Мощный генератор перем. напряжения, к-рый питается от источника исходного пост. напряжения, подключается к первичной обмотке трансформатора, а со вторичной обмотки снимается перем. напряжение нужной величины, к-рое затем выпрямляется. Постоянное выходное напряжение выпрямителя при необходимости стабилизируется с помощью стабилизатора, включенного на выходе выпрямителя, или путем управления параметрами перем. напряжения, вырабатываемого генератором (см. *Стабилизация тока и напряжения*). Для получения высокого кпд в П. и. применяются генераторы, работающие в т. н. ключевом режиме и вырабатывающие напряжение прямоуг. формы (см. *Логические схемы*). Выходные трансисторы генератора, коммутирующие напряжение на первичной обмотке, переключаются на закрытого состояния, а к-ром ток через трансистор не течет, в состоянии насыщения, в к-ром падение напряжения на трансисторе мало, рассеивая небольшую мощность.

В П. и. высоковольтных источников питания обычно используется дт самонадукции, возникающая на индуктивности при реакном прерывании тока. Прерывателем тока служит трансистор, работающий в ключевом режиме, индуктивностью является первичная обмотка повышающего трансформатора. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки и выпрямляется. Такие схемы вырабатывают напряжение до неск. десятков кВ и применяются для питания кинескопов, электронно-лучевых трубок и т. п. Качественно работа П. и. обеспечивает кпд порядка 80% и выше.

ПРЕОНЫ — гипотетич. элементарные объекты (частицы) из к-рых, возможно, состоят кварки и лептоны (см. *Составные лептоны лептонов и кварков*).

ПРЕЦЕССИЯ (от предцелит. *precessio* — предшествование) — движение тв. тела, имеющего неподвижную точку O , к-рое определяется изменением угла прецессии ψ (см. *Вектора углы*) и представляет собой вращение вокруг неподвижной оси Oz с угл. скоростью $\Pi. \omega = \psi$. Наряду с П. тело совершает свист. вращение с угл. скоростью Ω вокруг нежестко связанной с телом оси Oz (ось свист. вращений), а также нутационное движение, при к-ром происходит изменение угла нутации $\theta = z_0$ (рис.). Если во всё время движения $\theta = \text{const}$ (нутация отсутствует) и величины Ω, ω также остаются постоянными, то движение тела наз. р е г у л я р н о й П. Ось Oz описывает при этом вокруг оси П. Oz_1 прямой круговой конус. Такую П. при произвольных нач. условиях совершает закрепленное в центре тяжести симметрич. тело (гироскоп), на к-рое никакие силы, создающие момент относительно закрепленной точки, не действуют; ось П. в этом случае является неизменной направлением кинетич. момента

тела (см. *Момент количества движения*). Симметрич. тело, закрепленное в произвольной точке осн. симметрии и находящееся под действием силы тяжести (тяжелый гироскоп или волчок), совершает при произвольных нач. условиях П. вокруг вертикальной осн. совершающ. движение нутационными колебаниями, амплитуда и период к-рых тем меньше, чем больше угл. скорость

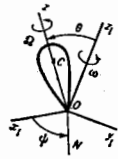


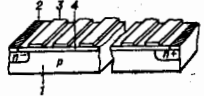
Схема прецессии тв. тела: Ox_1, Oy_1, Oz_1 — неподвижные осн. по отношению к которым движется тело, ON — прямая, перпендикулярная и плоскости z_0, z (Oz — линия углов), ψ — угол x_1, ON .

свист. вращении Ω . Когда $\Omega \gg \omega$, видимое движение гироскопа мало отличается от регулярной П.; такую П., сопровождающуюся нутационными ВЧ-колебаниями малой амплитуды, наз. п с е в о р е г у л я р н о й П. Угл. скорость псевдорегулярной П. тяжелого гироскопа приблизительно определяется равенством $\omega = Pa/Q$, где P — вес гироскопа, a — расстояние от неподвижной точки до центра тяжести, I — момент инерции гироскопа относительно осн. симметрии. Спротивляясь движению вызывает затухание нутационных колебаний, и П. постепенно становится регулярной.

Движение широко применяемых в технике гироскопич. систем носит характер псевдорегулярной П.; для изучения его используют обычно т. н. элементарную (прелесонозную) теорию гироскопич. явлений. Подробнее см. в ст. *Гироскоп*.

ПРИБОР С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ (ПЗС) — интегральная схема, представляющая собой совокупность МДП-структур, сформированных на общей полупроводниковой подложке т. о., что полоски электродов образуют линейную или матричную регулярную структуру. Расстояния между соседними электродами столь малы, что существенно становятся их взаимовлияние вследствие перекрытия областей пространственного заряда вблизи краев соседних электродов (рис. 1). Изобретён У. Бойлом (W. Boyle) и Дж. Смитом (G. Smith) в 1969. В ПЗС осуществляется направленная передача

Рис. 1. Структура прибора с зарядовой связью (фрагмент): 1 — кристалл кремния; 2 — вход; 3 — выход; 4 — металлические электроды; 5 — диэлектрик.



зарядов от электрода к электроду путем манипуляции электр. напряжениями на этих электродах. Заряды в ПЗС вводятся электр. (инжекцией) или фотоелектр. способами. Осн. функциональные назначения фоточувствит. ПЗС — преобразование оптч. изображений в последовательность электр. импульсов (формирование видеосигнала), а также хранение и обработка цифровой и аналоговой информации. Используются термин «прибор с переносом заряда» (ППЗ) и «фоточувствит. прибор с зарядовой связью» (ФПЗС). ПЗС изготавливают на основе монокристалла кремния. Для этого на поверхности кремниевой пластины методом термич. окисления создается тонкая (0,1—0,15 мкм) диэлектрич. пленка диоксида кремния (SiO_2). Этот процесс осуществляется т. о., чтобы обеспечить совершенство границы раздела полупроводник — диэлектрик и мин. концентрация рекомбинант. центров на границе. Электроды отд. МДП-элементов производятся на алюминии, их длина составляет 3—7 мкм, зазор между электродами $\approx 0,2$ —3 мкм. Типичное число МДП-элементов 500—

2000 в линейном и 10^4-10^6 в матричном ПЗС; площадь пластины $\sim 1 \text{ см}^2$. Под крайними электродами каждой строки изготавливают $p-n$ -переходы, предназначенные для ввода — вывода порции зарядов (зарядовых пакетов) элетрич. способом (шинковой $p-n$ -переходом). При фотоэлектрич. вводе зарядовых пакетов ПЗС освещают с фронтальной или тыльной стороны. При фронтальном освещении во избежание затекающего действия электродов алюминий обычно заменяют пленками высоколегиров. полекристаллич. кремния (полукремния), прозрачного в видимой и ближней ИК-областях спектра.

Принцип действия ПЗС на примере фрагмента строки ФПЗС, управляемой трёхтактовой (трёхфазной) схемой, иллюстрируется на рис. 2. В течение такта I (восприятие, накопление и хранение видеоинформации) к электродам 1, 4, 7 прикладывается т. н. напряжение хранения U_{xp} , отсчитываемое от осн. носителя — дырки в случае кремния p -типа — в глубь полупроводника и образующее обычные слои глубиной 0,5—2 мкм — потенц. ямы для электронов. Освещение поверхности ФПЗС порождает в объёме кремния избыточные электронно-дырочные пары, при этом электроны стягиваются в потенц. ямы, локализованы в тонком ($\sim 0,01$ мкм) приповерхностном слое под электродами 1, 4, 7, образуя сигнальные зарядовые пакеты. Величина заряда в каждом пакете пропорциональна экспозиции поверхности вблизи данного электрода. В хорошо сформированных МДП-структурах образующиеся заряды вблизи электродов могут относительно долго сохраняться, однако постепенно вследствие генерации носителей заряда примесных центров, дефектов в объёме или на границе раздела (темновой ток) эти заряды будут накапливаться в потенц. ямах, пока не превысят сигнальные заряды и даже полностью заполнят ямы.



Рис. 2. Схема работы трёхфазной строки с зарядовым связью — одиночного регистра.

Во время такта II (перенос зарядов) к электродам 2, 5, 8 и т. д. прикладывается т. н. напряжение считывания, U_c , более высокое, чем напряжение хранения U_{xp} . Поэтому под электродами 2, 5 и 8 возникает более глубокие потенц. ямы, чем под электродами 1, 4 и 7, и вследствие близости электродов 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 барьеры между ними исчезают и электроны перетекают в соседние, более глубокие потенц. ямы.

Во время такта III напряжение на электродах 2, 5, 8 снижается до U_{xp} , а с электродов 1, 4, 7 снимается. Т. о. осуществляется перенос всех зарядовых пакетов вдоль строки ПЗС вправо на один шаг, равный расстоянию между соседними электродами.

Во всё время работы на электродах, непосредственно же подключённых к потенциалам U_{xp} или U_c , поддерживается небольшое напряжение смещения $U_{см}$ (1—3 В), обеспечивающее объединение носителями заряда всей поверхности полупроводника и ослабление на ней рекомбинац. эффектов.

Повторяя процесс коммутации напряжений многократно, выводит через крайний $p-n$ -переход последовательно все зарядовые пакеты, возбуждённые, напр., светом в строке. При этом в выходной цепи возникают импульсы напряжения, пропорциональные величине заряда данного пакета. Картина освещённости трансформируется в поверхностный зарядовый рельеф, к-рый после продвижения вдоль всей строки преобразуется в последовательность элетрич. импульсов. Чем больше

число элементов в строке или матрице (число элементов разложения), тем точнее воспринимается изображение.

При небольшом числе переносов увеличиваются рекомбинац. потери, происходит неполная передача зарядового пакета от одного электрода к соседнему и усиливается обусловленные этим искажением информации. Чтобы избежать искажений накопленного видеосигнала из-за продолжающегося во время переноса освещения, на кристалле ФПЗС создают пространственно разделённые области восприятия — накопления и хранения — считывания, причём в первых обеспечивают макс. чувствительность, а вторые, наоборот, экранируют от света. В линейном ФПЗС (рис. 3, а) заряды, накопленные в строке 1 за один цикл, передаются в регистр 2 (из чётных элементов) и в регистр 3 (из

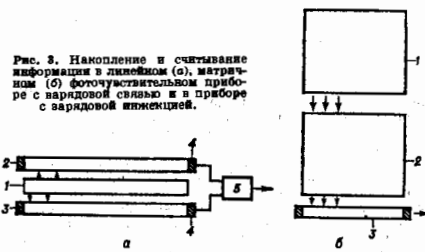


Рис. 3. Накопление и считывание информации в линейном ФПЗС: (а) фотоэлектрическом (б) фотоэлектрическом приборе с зарядовой связью и в приборе с зарядовой шиной.

нечётных). В то время, как по этим регистрам информация передаётся через выход 4 в схему объединения сигналов 5, в строке 1 накапливается новый видеокдр. В ФПЗС с кадровым переносом (рис. 3, б) информация, воспринятая матрицей накопления 1, быстро «сбрасывается» в матрицу хранения 2, из к-рой последовательно считывается ПЗС-регистром 3; в это же время матрица 1 накапливает новый кадр.

Осн. параметры ПЗС: амплитуды управляющих импульсов (U_{xp} , $U_c \approx 5-20$ В), отност. потери заряда при одном переносе ($\epsilon \sim 10^{-4}-10^{-6}$), макс. тактовая частота ($f_{такт} = 10-100$ МГц), макс. и мин. плотности зарядового пакета ($Q_{п, макс} \approx 50$ нКл/см²; $Q_{п, мин} \approx 50$ пКл/см²), динамич. диапазон ($D = 20 \lg Q_{п, макс} / Q_{п, мин} \approx 60-80$ дБ), плотность темнового тока ($I_{т} = 10^{-10}-10^{-9}$ А/см²). Для характеристики ФПЗС кроме перечисленных выше параметров указываются спектральный диапазон ($\Delta\lambda = 0,4-1,1$ мкм), fotocувствительность ($S_{ф} = 0,1-0,5$ А/Вт), макс. и мин. экспозиция ($H_{макс} \leq 300$ Дж/см²; $H_{мин} \geq 300$ Дж/см²), разрешающая способность ($r = 10-50$ линий/мм). Кроме ПЗС простейшей структуры (рис. 1) получили распространение и др. их разновидности, в частности приборы с полукремниевыми перекрытыми электродами (рис. 4, а), в к-рых обеспечиваются активное фотовоздействие на всю поверхность полупроводника и малый зазор между электродами, и приборы с асимметрией приповерхностных свойств (напр., слоем диэлектрика между ними — рис. 4, б), работающие в двухтактном режиме. Принципиально отлична структура ПЗС с объёмным каналом (рис. 4, в), образованным диффузией примесей. Накопление, хранение, перенос заряда происходит в объёме полупроводника, где меньше, чем на поверхности, рекомбинац. центров и выше подвижность носителей. Следствием этого является увеличение на порядок значения $f_{такт}$ и уменьшение ϵ по сравнению со всеми разновидностями ПЗС с поверхностным каналом.

Для восприятия цветных изображений используют один из двух способов: разделение оптч. потока с помощью призм на красный, зелёный, синий, восприятие каждого из них специальным ФПЗС — кристаллом,

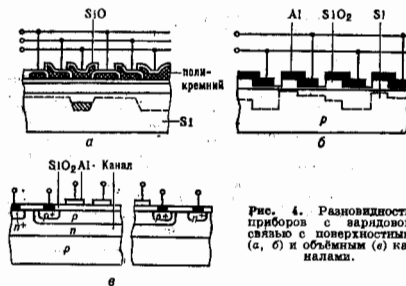


Рис. 4. Равновидности прибора с зарытовой связью с поверхностным (а, б) и обобщенным (в) капалкой.

сменяем импульсов от всех трёх кристаллов в единый видеосигнал; создание на поверхности ФПЗ плёночного стрипхового или мозаичного конденрующего светового фильтра, образующего растр из равноугловых триад.

Для восприятия изображений в ИК-области спектра равняются три направления: легирование кремния примесями (In, Ga, Te и др.) и использование примесного фотоэффекта; разработка ФПЗ на узкозонных полупроводниковых соединениях (напр., на In, Sb для диапазона $\Delta\lambda = 3-5$ мкм); создание гибридных структур, сочетающих фоточувствит. мишень, напр. на кристалле HgCdTe, и кремниевые ПЗС-регистры, обеспечивающие считывание информации, накапливаемой в мишени.

Осн. отличит. особенность ПЗС как изделия микроэлектроники является возможность вводить в кристалл и хранить без искажения большие массивы диффр. (в т. ч. многоуровневой) или аналоговой информации, использовать эл.итрич. и оптич. способы для ввода информации, осуществлять направленное распространение (в т. ч. циркуляцию) информации в кристалле и неразрушающий доступ к ней, проводить как последовательный, так и параллельный процесс обработки информации. От вакуумных приборов изображения (видикона) ФПЗС, кроме того, отличается жёстким геом. растром, позволяющим фиксировать координаты элементов разложения и исключать дисторсию и др. искажения растра, долговечностью, меньшей потребляемой мощностью, отсутствием микрофонного эффекта и выгорания под действием сильной засветки, нечувствительностью к магн. и эл.итрич. полям.

Осн. применение ПЗС находят в качестве безвакуумного твердотельного аналога видикона для восприятия и обработки видеoinформации в телевидении, устройствах техн. зрения, видеокамерах, электронных фотоаппаратах. Значительно меньше ПЗС используют в цифровой технике в качестве запоминающих устройств, регистров, арифметико-логич. устройств (см. *Логические схемы, Памяти устройств*) и в аналоговой технике в качестве линий задержки, фильтров и т. п.

Лит.: Семен К., Томасет М., Приборы с переносом заряда, пер. с англ., М., 1978; Носо в Ю. Р., Шилин В. А., Основы физики приборов с зарытовой связью, М., 1986; Пресс Ф. П., Фотоувствительные микроскопы с зарытовой связью, в кн.: *Итоги науки и техники. Сер. Электроника*, т. 18, М., 1988.

ПРИВЕДЕНИЕ СИЛ — преобразование системы сил, приложенных к твёрдому телу, в другую, ей эквивалентную систему сил, в частности простейшую. В общем случае любая система сил, действующих на твёрдое тело, при приведении к произвольному центру O , называемому центром приведения, заменяется одной силой, равной геом. сумме (гл. вектору R) сил системы и приложенной в центре приведения, и одной парой с моментом, равным геом. сумме (гл. моменту M_0) всех сил системы относительно центра приведения. В зависимости

от того, чему у данной системы сил равны R и M_0 , эта система может окончательно приводиться к одному из следующих простейших видов: а) к *паре сил* с моментом M_0 , когда $R = 0$, а $M_0 \neq 0$; б) к одной силе, т. е. к равнодействующей, равной R , когда $R \neq 0$, а $M_0 = 0$ или $M_0 \perp R$; в) к *динамическому вытуту*, когда векторы R и M_0 не равны нулю и не взаимно перпендикулярны. При $R = 0$ и $M_0 = 0$ система сил находится в равновесии. С. М. Тарг.

ПРИВЕДЕННАЯ МАССА — условная характеристика распределения масс в движущейся механической или смешанной (напр., эл.-механ.) системе, зависящая от физ. параметров системы (масс, моментов инерции, индуктивности и др.) и от закона её движения. В простейших случаях П. м. определяется из равенства $T = \frac{1}{2} \mu v^2$, где T — *кинетическая энергия* системы, v — скорость нек-рой характерной точки, к-рой и приводится масса системы. Напр., для тела, совершающего плоско-параллельное движение, при приведении к его центру масс С П. м. $\mu = [1 + (\rho_c/h_c)^2]m$, где m — масса тела, ρ_c — *радиус инерции* относительно оси, перпендикулярной к плоскости движения и проходящей через центр С, h_c — расстояние от центра масс до мгновенной оси вращения (в общем случае величина переменная). Обобщением понятия П. м. являются т. н. коэф. инерции a_{ik} в выражении кинетич. энергии системы со стационарными связями q_i , положение к-рой определяется в обобщённых координатах q_k :

$$2T = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k,$$

где \dot{q}_i, \dot{q}_k — обобщённые скорости, a_{ik} — *ф-ции обобщённых координат*. С. М. Тарг.

ПРИВЕДЕННОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ — термодинамич. уравнение состояния, записанное относительно безразмерных величин (приведённых переменных), определённых в масштабе критич. значений, П. у. с. $P' = P'(T', v')$ получается из обычного ур-ния состояния $P = P(T, v)$ заменой $P \rightarrow P'/P_c$, $v \rightarrow v'/v_c$, $T \rightarrow T' = T/T_c$ (P_c, v_c, T_c — критич. значения давления, уд. объёма v , темп-ры T , координаты критической точки). Параметры v_c, T_c (а следовательно, и $P_c = P(T_c, v_c)$) могут быть получены из совместного решения ур-ний

$$\frac{\partial P(T, v)}{\partial v} = 0, \quad \frac{\partial^2 P(T, v)}{\partial v^2} = 0,$$

являющихся необходимыми условием термодинамич. устойчивости критич. состояния системы. Использование приведённых переменных P', v', T' удобно в случаях, когда феноменологич. ур-ние состояния рассматриваемого систем $P = P(T, v)$ включает только два параметра, конкретизирующих систему данного класса (напр., параметры a и b в *Ван-дер-Ваальса уравнении*). В этом случае П. у. с. не содержит указанных параметров и универсально для всех систем, описываемых ур-ниями состояния данного типа (*соответственные состояния* законов). Термодинамич. особенности таких систем (уд. теплоёмкости, теллота фазового перехода, уд. объёма жидкой и газообразной фаз, кривая инверсии (см. *Джоуля — Томсона эффект*) и др.) также являются универсальными ф-циями v' и T' и, будучи определёнными (напр., экспериментально) для одной из таких систем, могут быть пересчитаны на другие.

В микрооснов. теории возможность существования универсальных ур-ний состояния может быть обоснована для систем, статистически невирожденных по отношению к трансляц. движению, когда $kT \gg h^2/m^3(NV)^{1/3}$, где V — объём системы, содержащей N частиц с массой m (см. *Статистическая физика*), и когда потенциал взаимодействия двух частиц классич. системы $\Phi(R) = U_0 \Psi(R/d)$, где R — расстояние между частицами, d — их эфф. диаметр, U_0 — параметр

интенсивности взаимодействия (ϕ -ция $\Psi(R/d) \sim (d/R)^n - (d/R)^m$; для потенциала Ленарда — Джонса $n = 12, m = 6$ (см. *Межмолекулярное взаимодействие*); для случая твердых сфер $n \rightarrow \infty$). Тогда ϕ введи безразмерные величины $\theta = kT/U_0, \varphi = V/d^3$ и т.е. $P \approx P_0$ можно показать, что термич. ур-ние состояния $P = P(T, \varphi)$ и калорич. ур-ние состояния для теплоемкости $C_{V,N} = C_{V,N}(T, \varphi)$, определяемые производными логарифма статистич. интеграла классич. идеальной системы, выражаются через θ и φ в виде зависимости от конкретных значений U_0 и d :

$$p = \pi(\theta, \varphi), \quad C_{V,N} = C_{V,N}(\theta, \varphi).$$

Т. о., из подобия потенциалов взаимодействия частиц в разл. физ. системах (т. е. в системах с одинаковой ϕ -цией ϕ) следует универсальность. П. у. с. Для каждого вида ϕ -ция ϕ существуют свои П. у. с.

Использование приведенных переменных естественно в полупедагогич. теории *критических явлений*. В ней предполагается, что существует нек-рый класс физически разл. систем (газ — жидкость, бинарный сплав, магнетик и др.), термодинамич. поведение к-рых в непосредств. близости к критич. точке или к точке *фазового перехода* является подобным. Поведение разл. термодинамич. величин аппроксимируется степенным законом по параметру $\tau = (T - T_c)/T$ (степени этого параметра $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 1 + \gamma/\beta$ наз. *критическими показателями*). Ур-ние состояния магнетика $M = M(T, h)$, где M — намагниченность, h — напряженность магн. поля, в переменных $m = M/|T|^\beta$ и $h = H/|T|^{\beta+\gamma}$ таково, что все изотермы сливаются в одну, имеющую две ветви, $m = m(h, \tau/|T|)$. Для ряда магнетиков этот вывод подтвержден экспериментально. Если ур-ние состояния магнетика определяется двумя параметрами A и B , разлчными для разных систем, напр. зависимость

$$h = mA(\mp 1 + Bm^{1/\beta})^\beta,$$

универсальной заданную с помощью критич. показателя поведения намагниченности $M \propto |T|^\beta$, изотермической восприимчивости $\chi \propto |T|^{-\gamma}$ и теплоемкости $C_V \propto |T|^{-\alpha}$ ($\alpha = 2 - 2\beta\gamma$), при приведенные значения $m = mB^\beta$ и $h' = h/AB^\beta$ позволяют получить П. у. с.

$$h' = m'(\mp 1 + (m')^{1/\beta})^\beta,$$

выражающее универсальный закон соответственных состояний магнетика в области критич. точки, к-рый в рамках гипотез подобия можно перенести на язык систем типа газ — жидкость и т. п.

Лит.: Вукалович М. П., Новиков И. И., Уравнение состояния реальных газов, М., 1948; К в а с е и н а И. А., Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем, М., 1991; см. также лит. при ст. *Соответственные состояния*, И. А. Косиничев.

ПРИГОДИНА ТЕОРЕМА — теорема *термодинамики неравновесных процессов*, согласно к-рой при данных условиях, препятствующих достижению системы равновесного состояния, стационарному (неравновесному, но неизменному во времени) состоянию соответствует минимум *производства энтропии*. Если таких препятствий нет, то производство энтропии достигает своего абс. минимума — нуля. Доказана И. Р. Пригодиной (И. Р. Prigogine) в 1947 в соотношениях взаимности Осенгера (см. *Осенгера теорема*). П. т. эквивалентна доказанному Осенгером (1931) принципу мин. рассеяния энергии и справедлива, если кинетич. коэф. в соотношениях Осенгера постоянны. Для реальных систем П. т. справедлива лишь приближенно, поэтому минимальность производства энтропии для стационарного состояния не является столь общим принципом, как максимальность энтропии для равновесного состояния (см. *Второе начало термодинамики*). Производством энтропии в неравновесной термодинамич. системе, к-рая описывается *n* независимыми тер-

модинамич. силами X_1, \dots, X_n , равно

$$\sigma = \sum_{i,k} L_{ik} X_i X_k.$$

Если термодинамич. силы X_1, \dots, X_m постоянны, то минимум σ соответствует условию $\delta\sigma/\delta X_i = 0$ при $i = m + 1, \dots, n$, откуда поток

$$I_i = \frac{1}{2} \frac{\delta\sigma}{\delta X_i} = \sum_k L_{ik} X_k = 0$$

(при $i = m + 1, \dots, n$), т. е. все потоки, кроме тех, к-рые поддерживаются постоянными, равны нулю. Справедливо и обратное утверждение: в стационарном состоянии σ минимально, поскольку σ — положительно определенная квадратичная форма.

В общем случае для непрерывной системы потоки и силы переменны в пространстве, т. е. зависят от точки x , и нужно рассматривать полное производство энтропии

$$P = \int \sigma(x) dV = \sum_{i,k} \int X_i(x) L_{ik}(x) X_k(x) dV,$$

где интегрирование ведется по объему V системы, $\sigma(x)$ — локальное производство энтропии. П. т. утверждает, что в стационарном состоянии функционал P минимален относительно вариации $X_i(x)$ при постоянных L_{ik} . Если L_{ik} не постоянны, то минимальность не имеет места. В общем случае P можно исследовать для нек-рых моделей. Напр., для системы, находящейся в контакте с термостатом в состоянии из независимых частей, каждая из к-рых может находиться в одном из двух энергетич. состояний, а также поглощать и испускать монохроматич. излучение, показано, что даже для далёких от равновесия состояний производство энтропии может очень мало отличаться от равновесного.

Лит. см. при ст. *Термодинамика неравновесных процессов*, Д. Н. Зубарев.

ПРИЕМНИКИ ЗВУКА — устройства, предназначенные для обнаружения звуковых волн (см. *Звук*). Измерения их характеристик (*звукового давления*, *набег*, *смещения*, *колебат. скорости*, *интенсивности* и т. д.) и для преобразования акустич. сигнала в электрич. с целью усиления, анализа, передачи на расстояние, записи. Навб. распространение получили П. з. — *электроакустические преобразователи*, к-рые позволяют воспринимать временную структуру акустич. сигнала; при малых волновых размерах П. з. с их помощью можно получить и пространственную структуру звукового поля. П. з. для воздушной среды наз. *микрофонами*, для водной — *гидрофонами*; для приёма звуковых волн в земной коре — *геофонами*; приём упругих волн на поверхности твёрдых тел осуществляется в *брометрах* и *микрофонах* и гидрофонах в большинстве случаев служат приёмниками звукового давления, однако существуют и приёмники градиента давления, приёмники колебат. скорости и комбинации. Приёмники для воздушной и водной среды. Эти функциональные особенности микрофонов и гидрофонов обеспечиваются как конструкцией приёмного элемента, так и электронной схемой первичной обработки выходного сигнала приёмника-преобразователя. Виброметры являются приёмниками *колебательного смещения частиц*, *колебательной скорости частиц* или *ускорения* (в последних двух случаях их наз. соответственно *веломерами* и *акселерометрами*), причём электронная схема, осуществляющая интегрирование или дифференцирование выходного сигнала, позволяет использовать один и тот же приёмный элемент для выполнения всех трёх ϕ -ций. Осн. характеристика П. з. — преобразовател. отношение чувствительность, представляющая отношение

выходного электр. сигнала к входному акустическому; для приёмников звукового давления чувствительность — отношение амплитуды электр. напряжения в режиме холостого хода к амплитуде звукового давления. Зависимость чувствительности от частоты, амплитуды сигнала и направления его прихода определяет соответственно частотную характеристику, динам. диапазон и направленность П. з.

По виду частотных характеристик П. з. подразделяют на широкополосные и резонансные. Первые позволяют принимать сложные по спектральному составу сигналы; они работают с пост. чувствительностью в широкой области частот, лежащей ниже первой собств. частоты механич. системы П. з., и используются, напр., при приёме речи и музыки, при исследованиях в гидроакустике и геоакустике, изучении шумов акустических рвал, происхождения и т. п. Вторые служат для приёма тональных сигналов с заданной частотой или узкополосных сигналов. Они обладают повышенной за счёт резонанса чувствительностью и применяются в режимах активной акустич. локализации в гидроакустике, дефектоскопии, медицинской диагностике, в разл. контрольно-измерит. УЗ-устройствах (см. Ультразвук). В акустоэлектронике используют как резонансные, так и широкополосные приёмники.

Динамич. диапазон П. з. определяется областью амплитуд сигнала, в к-ром чувствительность сохраняется неизменной; снизу он ограничен собств. шумами приёмного элемента, входных электр. цепей и внеш. шумами, сверху — нелинейностью свойств приёмника. Направленность П. з. определяется их волновыми размерами и конструктивными особенностями, она оказывает существен. влияние на направленность акустич. антенн. Для получения острой НЧ-направленности приёмники могут служить приёмники параметрич. типа, основанные на использовании нелинейных свойств среды, в к-рой распространяется звук (см. Параметрические излучатели и приёмники звука).

В качестве микрофонов в звуковом диапазоне частот служат преобразователи электродинамич., электростатич. типа, реже — пьезоэлектрические преобразователи. Чувствительность их составляет от единиц до сотен мВ/Па, динамич. диапазон — от десятков до сотен дБ. Электростатич., пьезоэлектр. и пьезополимерные измерит. П. з. применяются в воздушной среде на УЗ-частотах. В качестве гидрофонов служат в осн. преобразователи из пьезоэлектрических материалов. В гидроакустич. технике это гл. обр. П. з. из пьезо керамики с чувствительностью от единиц мкВ/Па до мВ/Па и динамич. диапазоном порядка 100 дБ. При измерениях в жидкостях на УЗ-частотах, а также при физ. измерениях в твёрдых телах, в дефектоскопии и др. областях УЗ-техники, в медицинской диагностике, в акустоэлектронике и т. п. наряду с пьезокерамик. преобразователями для приёма звука используются преобразователи на пьезокристаллах, плёночные пьезоэлектр. и магнетострикционные преобразователи, пьезополимерные и пьезополупроводниковые преобразователи. Выбор материала, конструкции и размеров П. з. в этих случаях в значит. степени определяется областью рабочей частот, к-рая может достигать гигагерцевой диапозона. Служат в качестве гидрофонов и оптоволоконные приёмники звука, основанные на акустооптич. преобразовании в волоконных световодах, по к-рым распространяются монокристалл. световые волны. Наряду с приёмниками-преобразователями, воспринимающими временною структуру акустич. сигнала, для газообразной и жидкой сред существуют П. з., измеряющие усреднённые во времени характеристики звуковой волны. К ним относятся приёмники механич. типа — *Релея диск*, *радиометр акустический*, а также тернич. П. з. Последние применяются, как правило, в жидкостях для измерения интенсивности ультразвува на ВЧ-диапозона. Они основаны на преобразовании энергии акустич. волны в тепловую. Возникающее при этом

нагревание среды измеряется посредством термоэлементов — термовар или термисторов, причём эдс термовара оказывается пропорциональной интенсивности звука. Для увеличения чувствительности тернич. П. з. термоэлементы покрываются слоем вещества с большой коэф. поглощения звука. Ниж. граница динамич. диапозона по интенсивности составляет у этих приёмников на частотах порядка единиц МГц величину порядка сотен В/м².

Виброметры, применяемые для измерений колебаний поверхности твёрдых тел, подразделяются на контактные и бесконтактные. Первые, к к-рым можно отнести и геофоны, имеют непосредств. механич. контакт с измеряемой поверхностью; чувствит. элементом в них является эл.-механич. преобразователь, как правило, пьезоэлектр. типа; на низких звуковых и на инфразвуковых частотах применяют преобразователи эл.-магн. или эл.-динамич. типа. В исследоват. практике обычно используют бесконтактные измерители амплитуды колебаний жёсткого или индуктивного типа. Для наиб. точных абс. измерений амплитуды колебл. смещений служат оптич. интерференц. методы, ниж. предел по амплитуде для к-рых составляет 10^{-3} — 10^{-4} мкм. Амплитуды порядка неск. мкм или десятков мкм измеряют с точностью не более 10% при помощи микроскопа по размытию хорошо освещённой точки на боковой поверхности колеблющегося тела. В качестве П. з. можно рассматривать и органы слуха животных и человека, производящие преобразование акустич. сигналов в нервные импульсы, передаваемые в центральную нервную систему (см. Слух, Физиологическая акустика).

ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ — устройства, предназначенные для обнаружения или измерения оптического излучения и основанные на преобразовании энергии излучения в др. виды энергии (тепловую, механическую, электрическую и т. д.), более удобные для непосредств. измерения. Они реагируют на интенсивность излучения, усреднённую по м. периодам колебаний светового поля, т. к. время релаксации приёмника, независимо от того, на каком принципе он основан, определяется процессами переноса и релаксации, к-рые происходят за время, много большее периода колебания светового поля.

Разнообразие типов П. о. и. определяется многочисленностью способов преобразования энергии и невозможностью создать П. о. и., одинаково чувствительные во всём оптич. диапазоне. По принципу действия П. о. и. делятся на следующие группы: тепловые (термоэлемнты, термоэлектр. приёмники, болометры, оптико-акустич. приёмники), фотонные, или фотоэлектрические (фотоэлементы, фотоумножители, вентильные фотоэлементы, фотодиоды, фототрубки, приёмники на эффекте уличения), фотодермоторные, фотохимические, а также глаза живых существ. По спектральному диапазону чувствительности П. о. и. разделяют на неселективные и селективные, чувствительность к-рых ограничена определ. участком спектра. Различают также одноэлементные и многоэлементные, охлаждаемые и охлаждаемые П. о. и.

Параметры приёмников оптического излучения. Свойства и возможности П. о. и. разл. типов характеризуют следующие параметры. Пороговая чувствительность — мин. поток излучения, вызывающий на выходе приёмника сигнал, равный напряжению собств. шумов или превышающий их в заданное число раз. Шумами наз. хаотич. сигналы со случайными амплитудами и частотами, возникающими в цепи включения приёмника при отсутствии измеремого потока излучения. Т. к. мощность шумов приёмника зависит от площади чувствит. площади приёмника и существуетна в полосе частот усилителя сигнала, то для

сравнения реал. приёмников служит пороговая величина потока излучения, отнесенная к единичной полосе пропускания (1 Гц), единичной площади (1 см²) и излучаемой в Вт/Гц^{1/2}/см. На практике используют обратную величину, измеряемую в см.Гц^{1/2}/Вт и называемую «обратной чувствительностью» — способностью. Эта характеристика, будучи независимой от размера чувств. площади, удобна для сравнения реал. типов приёмников.

Исследуют также чувствительность (коэф. преобразования) — отношение сигнала на выходе приёмника (тока или напряжения) к величине мощности оптич. излучения сложного спектрального состава, вызывающего появление этого сигнала; измеряется в А/Вт, В/Вт. В ряде случаев интегральная чувствительность выражается как отношение сигнала приёмника к величине освещённости его входного окна; измеряется в А/лм, В/лм.

Постоянная времени — время, за которое сигнал на выходе приёмника нарастает от нуля до значения, равного 0,63 от стационарного значения. Этот параметр служит мерой способности П. о. в. регистрировать оптич. сигналы мн. длительности, а также определяет максимально возможную частоту модуляции потока излучения, регистрации к-рому происходит ещё без искажения.

Спектральная чувствительность характеризует реакцию приёмника при действии на него монохроматич. (с длиной волны λ) потока излучения. Область спектральной чувствительности охватывает такой диапазон длин волн около данной конкретной λ , в к-ром чувствительность П. о. в. составляет не менее 10% своего макс. значения. Относит. спектральная чувствительность — зависимость отношения монохроматич. спектральной чувствительности к спектральной чувствительности в максимуме кривой спектральной чувствительности.

П. о. в. обладают и частотной характеристикой — зависимостью чувствительности приёмника от частоты модуляции падающего на него излучения. Вид этой характеристики определяется постоянной времени и видом модуляции.

Тепловые приёмники оптического излучения реагируют на энергию, поглощённую чувствительным приёмным элементом. Поглощённая энергия приводит к нагреванию чувств. элемента и повышению его темп-ры, к-рая может быть измерена непосредственно. Возможна регистрация и выведенных нагревом изменений к-л. др. ф-х параметров вещества этого чувств. элемента, напр. электропроводности, давления газа и т. п. Совр. тепловые приёмники позволяют обнаруживать повышение темп-ры термочувств. элемента при его облучении на 10⁻⁴—10⁻⁷ К и измерять мощности ~10⁻¹¹ Вт. Такое измерение темп-ры нельзя измерить непосредственно, применяют реал. косвенные методы. По принципу такого преобразования тепловые приёмники разделяются на неск. типов. Термомоменты (термопары) — П. о. в., основанные на термоэлектрич. Зеебека эффект — возникновении эдс в контуре из реал. материалов, спаян к-рых имеют неодинаковую темп-ру. На один из спаев контура направляется измеряемое излучение, что приводит к повышению темп-ры этого спаев по сравнению с темп-рой другого (холодного) спаев. Возникающая при этом эдс служит мерой измеряемого потока излучения. Металлич. термоэлементы изготовляют из Cu, Ni, Pt, константана и др.; а полупроводниковых элементов применяют: Sb, Si, Te и др. Для увеличения чувств. электр. сигнала вместо одного термоэлемента используют систему последовательно включённых термоэлементов. Такие системы на термостойких материалах. Результатирующая эдс термостойка равна сумме эдс входящих в него термоэлементов. Для уменьшения уровня помех термоэлементы (термостойки) помещают в вакуум, окружают охлаждаемыми экранами, применяют к омовещ. схемы,

в к-рых два одинаковых термоэлемента включены навстречу друг другу. Лучшие термоэлементы имеют следующие параметры: постоянная времени (1—3)·10⁻³ с, порог чувствительности (4—6)·10⁻¹¹ Вт/Гц^{1/2}/см, коэф. преобразования Ф₁—20 В/Вт.

Пирозлектрич. приёмники основаны на способности сегнетоэлектрич. материалов создавать электр. заряды на своей поверхности при вызванных нагревом механич. деформациях. Приёмники этого типа представляют собой тонкую пластинку, вырезанную определ. образом из пирозлектрич. кристалла, на к-рую нанесены металлич. электроды в слой поглощающей черни. Излучение, падающее на черну, вызывает нагрев кристаллич. пластинки и появление зарядов на электродах. Пороговая чувствительность пирозлектрич. приёмников не зависит от размера площади чувств. элемента (изменяется от 0,25 до 400 см²), и потому они могут иметь реал. конструкторские формы. Пирозлектрич. эффектом обладают кристаллы триглинисульфата, ниобата лития, керамики типа цирконата-титаната бария или оксида и др. Параметры пирозлектрич. приёмников зависят в широких пределах: постоянная времени: 2·10⁻³—2·10⁻² с.; порог чувствительности: 1·10⁻⁹—1·10⁻⁷ Вт/Гц^{1/2}/см; коэф. преобразования: 5—10⁴ В/Вт. В длинноволновой области спектра этот приёмник является единственным, работающим при ВЧ-модуляции без охлаждения. Спектральная область работы определяется областью поглощения «поглощающей черни».

Болометры — приёмники, действие к-рых основано на изменении нек-рых ф-х параметров чувств. элемента при его нагревании вследствие поглощения потока излучения. Наиб. распространение получили болометры «сопротивления», основанные на зависимости электр. сопротивления металла от модулирующей температуры. Термочувств. элемент болометра представляет собой тонкий слой металла (Ni, Au, В и др.), поверхность к-рого «покрывается» слоем черни, имеющей большой коэф. поглощения в широкой области длин волн. Полупроводниковые болометры (гермисторы) изготовляют из Ge, Si, S, также из оксидов Ni, Mn, Co. Сверхпроводящие болометры работают при глубоком охлаждении (3—15 К). Они основаны на резком изменении сопротивления металла в области перехода его от нормального состояния к сверхпроводящему. Для уменьшения влияния тепловых помех болометры делают компенсат. типа, когда в два плеча мостовой схемы включены одинаковые термочувств. элементы. Излучение направляют на один элемент; а другой «служит» для компенсации изменений темп-ры окружающей среды и резких помех. Для уменьшения порога чувствительности площадь болометра делают достаточно небольшой, а для уменьшения постоянной времени — очень тонкой. Типичные размеры болометра: площадь 0,3 мм², толщина 0,1—0,01 мкм. Порог чувствительности металла. болометров, работающих без охлаждения, при «объекте» безотражательности 5—500 мк составляет 10⁻¹⁰—10⁻⁹ Вт/Гц^{1/2}/см при коэф. преобразования 5—25 В/Вт и постоянной времени 2·10⁻³ с. Типичные параметры полупроводниковых болометров, работающих как без охлаждения, так и с глубокой охлаждением: объект, сопротивление 2—10 МОм, коэф. преобразования 50—5000 В/Вт, пороговый поток 10⁻¹¹—10⁻¹⁰ Вт/Гц^{1/2}, постоянная времени (1—5)·10⁻³ с. Для сверхпроводящих болометров из диоксида ниобия, Pt и Ge порог чувствительности составляет 10⁻¹²—10⁻¹⁰ Вт/Гц^{1/2}/см, постоянная времени 10⁻³—10⁻² с.

Опτικο-акустич. приёмники имеют К. мн. относится приёмники, у к-рых повышение темп-ры, вызванное поглощением излучения, непосредственно преобразуется в механич. работу регистрирующего устройства. Оптико-акустич. приёмник представляет собой небольшую герметич. камеру, наполненную газом, (гелием, двуокисью углерода) и к-рой расположена за-

чернильной пластины. Одной из сторон камеры служит окно, прозрачное для излучения, а другой — гибкая мембрана. Излучение, падающее на зачернившую пластину, нагревает ее, что приводит к повышению температуры и давления газа в камере. Обычно в оптико-акустич. приемник направляют модулиров. излучение, и потому мембрана колеблется с амплитудой, зависящей от мощности потока излучения. Изменение кривизны мембраны преобразуется в акустич. сигнал, и-рый может быть измерен. Оптико-акустич. приемники без зачернившей пластины называются вакуумными оптич. излучения непосредственно в газом, заключенном в камере. Пульсация давления газа улавливается микрофоном, сигнал о и-рого усиливается и измеряется. В этом случае оптико-акустич. приемник является селективным, т. к. он обладает чувствительностью только в опред. областях спектра (в пределах поглощения газа). Постоянная времени оптико-акустич. приемников (2—3) · 10⁻² с, порог чувствительности 4 · 10⁻¹⁰ Вт/Гц^{1/2}; коэф. преобразования 10⁴ В/Вт.

Фотоэлектронные приемники оптич. излучения непосредственно преобразуют э-м. энерг. излучение в электрический. Их разделяют на П. о. в. с внешним и внутренним фотоэффектом.

Фототелевизионный эл.-вакуумный прибор, преобразующий оптич. излучение в электрич. сигнал, основан на явлениях эмиссии электронов с поверхности твердого тела при поглощении фотонов. Красная граница чувствительности таких приемников определяется длиной волны, соответствующей поверхности твердого тела. Для большинства металлов она лежит в видимой и ближней ИК-областях, для полупроводников — в области вакуумного ультрафиолета. Простейшим фотоэлементом с внеш. фотоэффектом представляется собой вакуумированный оптический баллон, на части, выходящей из к-рого имеется фоточувствит. слой (фотокатод). В диэвр. баллоне выходящий слой и виде сетки или катоды между анодом и катодом приложены к разности потенциалов, создающая ускоряющее электрич. поле. Электрон, вылетающий из фотокатода при его освещении, попадает под действием поля на анод, создавая ток во внешней цепи. Область спектральной чувствительности фотоэлемента зависит от материала фотокатода. Всего существует 15 типов спектральных характеристик фотокатодов. Широко распространение получили три типа фотокатодов: Sb — Cs в области чувствительности 180—250 нм; Ag — O — Cs — 400—1000 нм; мультищелевой (Sb, K, Na, Cs) — 400—80 нм. В основу их, освещая и. т.д. фотоэлементы имеют тот (или, в а м е т р и ч е с к и й) материал собственной термоэмиссионной фотокатода. Порог чувствительности фотоэлемента определяется флуоресценцией, темновое токи на фоне к-рого измеряется фототок. Ср. величина темнового тока зависит от вида фотокатода и разности потенциалов между анодом и катодом. При комнатной температуре плотность темнового тока у мультищелевого фотокатода составляет 10⁻¹¹—10⁻¹² А/см². У фотокатода типа Ag — O — Cs — 10⁻¹¹—10⁻¹² А/см². Охлаждение фотокатода до темп-ры жидкого азота (77 К) приводит к снижению темнового тока на три-четыре порядка, но, и одновременно, уменьшению порога чувствительности. Постоянная времени вакуумных фотоэлементов составляет 10⁻⁸ с.

Фотодетекторный умножитель (ФДУ) — эл.-вакуумный прибор, преобразующий оптич. излучение в электрич. сигнал с последующим его усилением за счет вторичной эмиссии, суть к-рой состоит в испускании электронов поверхностью твердого тела при ее бомбардировке электронами большой энергии. Т. к. число вторичных электронов превышает число первичных, то, многократно повторив такой процесс, можно получить значит. усиление первичного электронного тока. У овер. ФДУ от 12 каскадами (десятью) коэф. усиления достигает 10⁸. Спектральная чувствитель-

ность ФДУ определяется типом фотокатода и полосой пропускания материала входного окна. Постоянная времени ФДУ составляет 40⁻⁹—10⁻⁸ с. Порог чувствительности ФДУ, как и у фотоэлементов, определяется флуоресценцией темнового тока, а также флуоресценцией вторичного тока вторичной эмиссии динодов и составляет 10⁻¹²—10⁻¹¹ Вт/Гц^{1/2}. Для снижения величины темнового тока и порога чувствительности применяют охлаждение. Кроме ФДУ с дискретными эмиттерами, используют ФДУ с непрерывными эмиттерами в форме нити (каллоны ФДУ). В простейшем случае ФДУ этого типа представляют собой трубку из диэлектрика (кварц, стекло), внутр. поверхность к-рой покрыта слоем полупроводника. К концам трубки приложено напряжение 2—3 кВ, создающее вдоль нее электрич. поле. Один конец трубки располагается вблизи фотокатода; второй конец располагается около коллектора для сбора электронов. Обычно длина трубки 100—150 мм, diam. 1,5—2,0 мм. Коэф. усиления каллонового ФДУ достигает 10⁸. Для увеличения чувствительности фотокатодов, применяемых в фотоэлементе и ФДУ, используют многократное прохождение излучения через фотокатод за счет полного внутр. отражения на границах раздела стекло — воздух и фотокатод — вакуум. Световой луч вводится в фотокатод под нужным углом с помощью призм, находящихся в оптическом контакте с плоским входным окном приемника. При многократном прохождении через фотокатод излучение почти полностью поглощается; при этом порог чувствительности приемника не теоретич. предел.

При регистрации оптич. излучения, модулированного частотой (100 МГц), используют спец. вид фотоприемников с в. и в. н. и фотоэффектом. К их числу относятся динамич. и статич. ФДУ со скрещенными полями, вакуумные фотодины, СВЧ-фотоэлементы, фотоэлементы и ФДУ будущей волны, импульсные скоростные фотоэлементы.

Фоторезисторы (фоторепротивляющие) — простейшие полупроводниковые структуры с одним типом проводимости, у к-рых под действием падающего оптич. излучения происходит изменение проводимости вследствие образования в них носителей заряда (электронов и дырок). Этот эффект наблюдается в полупроводниках при энергии падающего фотона, недостаточной для возникновения внеш. фотоэффекта, но достаточной для перехода носителя из валентной зоны в зону проводимости. Фотон с такой энергией вызывает внутр. фотоэффект, увеличивая в зоне проводимости и в валентной зоне число носителей заряда. Величина запрещенной зоны определяет красную границу чувствительности фоторезисторов. Фоторезистор представляет собой тонкую пластинку или пленку из полупроводника, нанесенную на подложку из изоляц. материала и помещенную в корпус с защитным окном; через контакты к чувствит. слою подводится питающее напряжение. Охлажденные фоторезисторы обычно монтируют на внутр. дне сосуда Дьюара. Схемы включения фоторезисторов аналогичны схемам включения болометров. Приемник, чувствительный в ДВ-области спектра, изготовляют из материала с узкой запрещенной зоной. Однако чем уже запрещенная зона, тем больше носителей возбуждается не фотонами, а термич. путём. Приято считать, что фоторезисторы, чувствительные к излучению с длиной волны до 3 мкм, охлаждение не требуют; в диапазоне 3—8 мкм необходимо охлаждение до 77 К; фоторезисторы для диапазона 8—30 мкм требуют глубокого охлаждения до 3—5 К. Наиб. широкое применение получили фоторезисторы на основе сульфида цинка (рабочая область спектра 0,3—0,9 мкм), селенида кадмия (0,35—1,4 мкм), сульфида свинца (0,4—3,6 мкм), селенида свинца (0,64—4,0 мкм), антимонаид кадмия (2,2—4,9 мкм), германия, легированного вольфом и ртутью (1,6—9,0 мкм). Постоянная времени фоторезисторов определяется временем установления стационарного состояния нормированных носителей заряда, во-

никающих при освещении, зависит от природы полупроводника и варьируется для разл. фотодетекторов от 10^{-2} до 10^{-8} с. Пороговая чувствительность фотодетекторов составляет 10^{-10} — 10^{-13} Вт/Гц^{1/2}.

Применяя и изменение с p - n -переходом могут работать в фотогальванич. или фотодиодном режимах. В первом случае дрейфчики при образовании генерирует эдс без внем. источника питания, во втором — к дрейфчику подводится внем. напряжение, и ток, проходящий через нагрузочное сопротивление, изменяется в зависимости от освещенности p - n -перехода. Особую группу составляют фотогальванич. приемники с ионным легированием, напр. HgCdTe. Обнаружит. способность дрейфчиков на основе донорлегиров. переходов равна $7 \cdot 10^{-10}$ Гц^{1/2}/Вт при длине волны 10,6 мкм и темп-ре 77 К. Фотогальванич. приемники на основе сплава PbSnTe в спектральной области 8—12 мкм обладают обнаружит. способностью $2 \cdot 10^{-10}$ Гц^{1/2}/Вт и постоянной времени $1,5 \cdot 10^{-6}$ с.

Особую группу фотогальванич. дрейфчиков составляют приемники с продольным (для латеральных) фотоэффектом. Суть эффекта состоит в том, что при неравном освещении p - n -перехода возникает поперечная эдс между p - и n -областями образует эдс, направленная вдоль перехода. Продольный фотоэффект на p - n -переходе используют в координатно-чувствит. приемниках, предназначенных для определения координат точки, в которую сфокусировано излучение.

Вторым типом приемников с p - n -переходом являются фотодиоды. Они отличаются от фотогальванич. приемников тем, что на них подается внешнее запирающее напряжение. В таких приемниках носители заряда уменьшают сопротивление переходного слоя, вызывая увеличение тока в цепи. Наиб. широко используются фотодиоды на Ge и Si, а также фотодиоды на основе полупроводниковых соединений: InAs, GaSe, InSb. Осн. преимуществом германиевых и кремниевых фотодиодов является то, что они не требуют охлаждения.

Значит. увеличения чувствительности достигают в лавинных фотодиодах и фототриодах (фототранзисторах). Лавинные фотодиоды основаны на явлении лавинного электрич. пробоя p - n -перехода лавинообразного роста числа носителей заряда, размокающих ударной ионизацией. Лавинное усиление тока достигает величин (2—3) $\cdot 10^4$ у германиевых и 10^4 — 10^6 у кремниевых лавинных фотодиодов. Порог чувствительности лавинных фотодиодов, работающих в режиме счѣтчика фотонов, достигает 10^{-17} Вт/Гц^{1/2}.

Фототриоды отличаются от фотодиодов дополнит. усилением фототока на втором p - n -переходе. Фототриод соединяет в себе свойства фотодиода и усилит. свойства транзистора. Однако наличие дополнит. перехода приводит к сильному снижению чувствительности этих дрейфчиков. Спектральные характеристики фототриодов такие же, как и у фотодиодов из аналогичных материалов.

Другие типы приемников оптического излучения. Для регистрации сверхкоротких импульсов лазерного излучения ИК-диапазона разработаны П. о. и., основанные на увеличении векторных потоками. При взаимодействии излучения с веществом (внутрянное поглощение на свободных носителях, переходы между подзонами в валентной зоне) вдоль направления распространения излучения возникает движение носителей заряда вследствие наличия у волн конечного импульса. Это движение носителей регистрируется в виде тока или напряжения. П. о. и. такого типа имеют достижимую времени 10^{-11} — 10^{-10} с., не требуют приладит. охлаждения и использования источников питания. Ещё больше временное разрешение до 10^{-14} — 10^{-13} с. может быть получено при использовании приемников с майорантальной основой структур металл — оксид — металл, работающих как туннельный диод. Недостатком

дрейфчиков этого типа является их малая чувствительность.

Полупроводниковые (механические) П. о. и. реагируют на давление света, для измерения к-рого служат разл. типы датчиков (ёмкостный, пьезоэлектрический), но чаще всего используют кристаллич. васы. Значит. увеличение чувствительности кристаллич. васы достигается заменой торсионного поддона чувств. элементов бесконтактным, поднесом в магн. поле. Ёмкостные кристаллич. колебатели при этом может быть уменьшены на 3—4 порядка. Однако применение дрейфчиков этого типа ограничено, т. к. они очень чувствительны к вибрациям и тепловому излучению окружающей среды.

К фотокимическим П. о. и. относятся все виды фотослов, используемые в сф. фотографии. Несмотря на различия между отд. фототр. процессами, они могут быть разделены на две группы: процессы на галогеносеребряных материалах и процессы на фотопроводящих материалах, к-рые наз. также электрофототр. процессами. Фототр. процесс состоит из двух стадий. Первая стадия — образование скрытого изображения под действием излучения в процессе экспонирования. Вторая стадия — визуализация скрытого изображения путѐм проявления и его закрепления для повышения стойкости к внем. воздействиям. Под действием света после проявления и фиксации в светочувствит. слое создается стойкое фототр. изображение. Мерой величин поглощенной энергии служит оптическая плотность проявленного фотослов. В зависимости от назначения галогеносеребряные слои имеют широкий диапазон чувствительности (10^{11} — 10^{17} Дж/см²) и разрешающей способности (25 и 2000 мкм⁻¹ соответственно). Электрофототр. материалы имеют чувствительность от 10^{-7} (селеновые слои), до 10^{-9} Дж/см² (фоторезисты, слои); разрешающая способность соответственно 94 и 1000 мкм⁻¹.

П. о. и. могут быть отнесены к классу живых существ. Область спектра, к-рой чувствителен глаз человека (0,4—0,7 мкм), наз. видимой областью. Человеческий глаз — селективный приемник с макс. чувствительностью ок. 555 нм. Оптич. схема глаза образует на сетчатке, содержащей светочувствит. элементы (палочки и колбочки), действительное перевернутое изображение предмета (см. Зрение). Диаметр зрачка глаза в зависимости от условий освещенности изменяется от 1,5 до 8,0 мм, освещенность сетчатки глаза при зр. изменении примерно в 30 раз. Адаптарованный к темноте глаз человека имеет пороговую чувствительность 10^{-17} Вт/Гц^{1/2}, что соответствует десяткам фотонов в 1 с. Своёю глазу видеть реально две близко расположенные точки предмета наз. разрешающей способностью; она характеризуется угл. пределом разрешения. Глаза др. живых существ отличаются большим разнообразием, напр. глаза нек-рых насекомых реагируют на поляризов. свет.

Для получения двумерного изображения наилучшего объекта служат многоэлементные П. о. и. с дискретно или непрерывно распределенными по поверхности приемными элементами. К ним относятся фотопластины, фотопленки, электронно-оптич. преобразователи, многоэлементные полупроводниковые болометры и фототриоды, автотриоды (см. Дальномеропластины).

П. о. и. применяются в спектроскопии, автотриодной электронике, астрономии, космич. исследованиях, автоматич. системах управления и т.д.

Лит.: Берковский А. Г., Гаванин В. А., Зайдел И. И., Вакунские фотоэлектрич. приборы, 2 изд., М., 1982; Криксулов Д. З.; Справочник по основам инфракрасной техники, М., 1978; Справочник по лазерам, пер. с англ., под ред. А. М. Прохорова, 2 т., М., 1978; Кремер в. ч. ур. и др. Л. С., Ро. Я. и др. О. В., Широкополосные приемники излучения, К., 1979; Базилев. Я. Н., Полупроводниковые приемники излучения, И. Вакунские, 1983; Фотоэлектрич. приборы и ИК-диапазона, под ред. Р. Дж. Кнеса, пер. с англ., М., 1985; А. Кеннеди М. Д., Баракоскино М. Д., Приемники оптического излучения, М., 1987.

Л. Н. Канорский,

ПРИЕМНЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ — класс электронно-лучевых приборов, предназначенных для визуального отображения информации, поступающей в виде электрич. сигналов. По характеру осн. применения выделяют: «чёрно-белые и цветные киноскопы для вещат. телевиз. приёмников; монохромные и цветные индикаторные приборы в киноскопич. полев. чёткости для отображения условной цифро-буквенной, графической и полнотонной информации в дисплеях ЭВМ, разл. рода системах управления, радиолок. устройствах, многофункциональных самостоятел. индикаторах, информ. системах и т. п.; осциллографич. трубки для график. представления хода биосинтезирующих периодических и однократных процессов, данные о к-рых могут быть выражены электрич. сигналами. Различают также П. э.-л. т. прямого наблюдения и проекционные трубки, изображение с экрана к-рых проецируется со «железят. увеличением» на отд. экран. Проекциионные П.-э.-л. т. по принципу работы бывают самосветящимися, в «м-х» электронн. пучок возбуждает излучение люминесцентного экрана или полупроводниковой лазерной «шпильки», и светомодулирующие, в к-рых пучок «замещает» к-л. оптич. свойства среды, что используется для пространственно-временной модуляции широкого светового потока от отдельного мощного источника света. Нев-рые виды индикаторных и осциллографич. П. э.-л. т. позволяют в течение длит. времени воспроизводить однократно поступившую информацию (см. *Запоминающая трубка*).

Фокусировка электронного пучка в большинстве совр. П. э.-л. т. осуществляется эл.-статич. полями, отклонение «л» изменением во времени полей, в к-х несколько индикаторных П. э.-л. т. — магнитным, в осциллографич. — электрич. полями. Процесс воспроизведения информации на экране наз. записью. В телевиз. приёмниках и нек-рых др. системах пучок отклоняется построчно, образуя ряд, состоящий из большого числа линий. При этом входной сигнал, несущий информацию, подается на элемент П. э.-л. т. управл. кинескопом интенсивностью пучка, в следствием и яркостью соответствующего участка изображения. Такой способ записи наз. *рестриком*. При др. способе записи широко применяемом для отображения цифро-буквенной и график. информации и называемом функциональным или векторным, входные сигналы управляют положением пучка по обемн. координатам экрана, выписывая при копировании пучка в соответствующие моменты времени *вектор. график*, *чертежи* и т. п. В осциллографич. П. э.-л. т. пучок периодически отклоняется в одном направлении (ось времени) с заранее установленной скоростью; *входной сигнал*, отражающий к-л. процесс во времени, управляет положением пучка в перпендикулярном оси времени направлении, благодаря чему процесс отображается в виде *графика* и прижигот. системы координат.

Осн. функциональные параметры П. э.-л. т.: разрешающая способность (выражается шириной светящейся линии, возбуждаемой перемещающимся электронным пучком, или числом разрывных линий, размещаемых на высоте кадра, либо предельном объёмом отображаемой информации); яркость свечения экрана, или *задаваемый световой поток*; контраст изображения, определяемый отношением яркости возбуждаемых и не возбуждаемых участков экрана; чувствительность отклонения (для осциллографич. П. э.-л. т.) — отклонение пучка на экране на 1 В отклоняющего напряжения. Параметры П. э.-л. т. противоречивым образом связаны между собой. Так, увеличение тока пучка для повышения яркости приводит к снижению разрешающей способности. Для преодоления этого противоречия созданы П. э.-л. т., в к-рых информация воспроизводится параллельно в разных местах экрана *неск. пучками*. Для управления интенсивностью каждого пучка необходим свой усилитель сигналов, полтора пропускания каждого по к-рых соответственно сумается.

Лит.: Мэнделер В. А., Куракин Л. А., Приемные электронно-лучевые трубки, 2 изд., М., 1971; Шерстюк В. Г., Электронная оптика и электронно-лучевые приборы, М., 1971; В. Д. Гигин.

ПРИМЫ ОПТИЧЕСКИЕ — примы из материалов, прозрачных для оптического излучения в нек-ром интервале его частот. Они могут быть и могут не быть прозрачны в строгогом смысле (напр., с усечённой вершиной) П. о. подразделяются на три обширных и резко различающихся по назначению класса: *спектрально-прозрачные* (пропускающие или дисперсионные примы), *отражательные примы* и *поляризационные примы*.

ПРИЛИПАНИЕ электронов — образование отрицат. ионов с участием свободных электронов. Сюда относятся с процессом диссоциативного П. и тройной процесс (с участием трёх частей) П. иона к атому или молекуле. Подробнее см. в ст. *Отрицательные ионы*. В. М. Смирнов.

ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ — проводимость полупроводника, при к-рой осн. вклад в перенос заряда дают электроны (дырки), термически возбуждённые в зону проводимости (валентную зону) из локализованных в запрещённой зоне донорных (акцепторных) состояний (проводимость *n*-типа и *p*-типа). П. п. определяется концентрацией донорных N_d и акцепторных N_a примесей и доложеном их уровней в запрещённой зоне. При высоких темп-рах T , если допуроводник невырожден, концентрация n носителей в собственном полупроводнике (см. *Собственная проводимость*) удовлетворяет условию $n_i \gg N_d - N_a$, наличие примесей незначительно сказывается на концентрациях электронов n и дырок p :

$$\left\{ \frac{n}{p} \right\} \approx n_i \pm \frac{1}{2} (N_d - N_a)$$

При этом все примеси ионизованы, а уровень Ферми E_f близок к середине запрещённой зоны. При более низких темп-рах, для к-рых $n_i \ll N_d - N_a$, почти все молекулы примесей остаются ещё неизменными (область истощения). В этом случае $n \approx N_d - N_a$; $p = n_i / (N_d - N_a) \ll n$, т. е. концентрация осн. носителей не зависит от T . При дальнейшем понижении T , E_f приближается к уровню E_d донорной примеси, а заселённость донорных уровней будет расти за счёт поступления электронов на зоны проводимости, а концентрация зонных носителей заряда соответственно уменьшится. При $T \rightarrow 0$ К концентрации зонных носителей убывает экспоненциально, в этом пределе доминирует *примесная проводимость*.

Лит.: см. ст. *Полупроводники*, И. Л. Бейлисс.

ПРИМЕСНЫЕ УРОВНИ — энергетич. состояния (уровни) полупроводника, расположенные в запрещённой зоне в обусловленные присутствием и в/м примесей и структурных дефектов. В зависимости от того, мало или равнона с шириной запрещённой зоны E_g расстояние от П. у. до края ближайшей разрешённой зоны, различают *мелкие* и *глубокие* П. у. По способности примесного атома отдавать электрон в зону проводимости либо принимать его из валентной зоны П. у. подразделяют на *донорные* и *акцепторные* (рис.). Мелкие П. у., соответствующие примесям замещения (замещающие атомы кристалла примесных атомов), проявляют донорный характер, если валентность примесного атома превышает валентность атомов осн. кристалла, или акцепторный — при обратном соотношении. Глубокие П. у. обычно образуются при замещении атомов матрицы атомами, отличающимися по валентности более чем на ± 1 . Такие примеси иногда способны образовывать *неск. П. у.*, соответствующих разл. зарядовым состояниям, напр. атом Си в Ge создаёт три П. у., соответствующих ионам Cu^+ , Cu^{2+} , Cu^{3+} . Глубокие П. у., отвечающие разным ионам, могут иметь разл. характер (одни — быть донорными, другие — акцепторными).

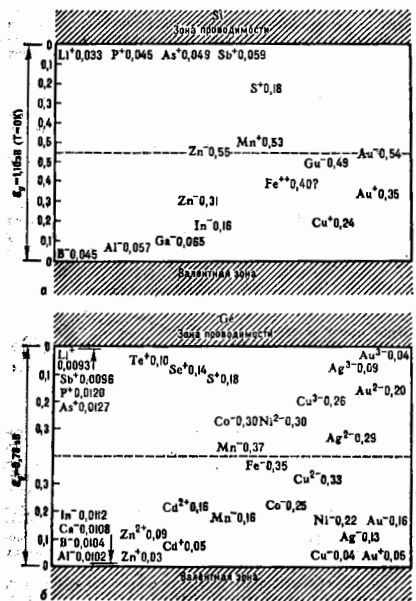


Схема уровней энергии различных примесей в Si (а) и Ge (б).

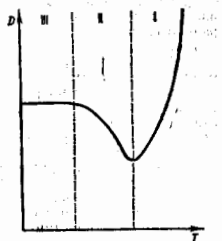
В случае примесей внедрения донорный или акцепторный характер П. у. не зависит от их валентности, а определяется величиной электростатичности. Если электростатичность у примесных атомов больше, чем у атомов матрицы, то П. у. акцепторным, в обратном случае — донорными. Одна и та же примесь может быть донором при замещении и акцептором при внедрении (напр., O в Si) либо наоборот.

П. у. локализованы вблизи дефектов. При очень высоких концентрациях примесей волновые ф-ции, соответствующие П. у., перекрываются, что приводит к образованию П. у. в примесных зонах.

Лит. см. при ст. Полупроводники. Д. М. Даштеин.
ПРИСОЕДИНЕННЫЙ АТОМ — атом кристалла, хим. природа к-рого отлична от хим. природы осн. атомов, образующих кристалл. П. а. относится к точечным дефектам и приводит к нарушению строгой периодичности идеального кристалла. П. а. располагаются либо в узлах кристаллич. решетки, заменяя осн. атомы (примесь замещения), либо в междоузлиях (примесь внедрения).
ПРИМОСОН — квазичастица, характеризующая поведение примесного атома в *квантовых кристаллах*. Вещание большой величины амплитуды нулевых колебаний атомов в квантовых кристаллах любые точечные дефекты решетки, в т. ч. примесные атомы, при низких темп-рах деалюализуются и превращаются в квазичастицы, практически свободно движущиеся через кристалл. Соотопение П. характеризуется квазинимпульсом ρ и энергетич. спектром $\epsilon(\rho)$, имеющим аномальную структуру (см. *Дефект*).

Движение П. определяет процессы диффузии. Схематично вид температурной зависимости коэф. диффузии D для П. приведен на рис. В области I (высокие

темп-ры) движение П. осуществляется в осн. с помощью термоактивац. механизма и коэф. диффузии экспоненциально падает с понижением темп-ры. Это либо классич. диффузия, при к-рой примесный атом переходит в соседний узел кристаллич. решетки, преодолевая нек-рый энергетич. барьер, либо диффузия, обусловленная наличием в кристалле термоактивиров. подвижных вакансий (в а к а с и о н о в). В первом случае показатель экспоненты в выражении для коэф. диффузии задается высотой барьера, а во втором — энергией активации вакансион и, в отличие от обычных кристаллов, вообще не зависит от типа примеси. В области II движение П. является зонным, а длина свободного пробега П. в кристалле ограничена их столкновениями с тепловыми возбуждениями (напр., с фононами), число к-рых убывает при понижении T . Это приводит к росту коэф. диффузии при охлаждении кристалла, что совершенно не свойственно для диффузии дефектов в обычных твердых телах. При низких темп-рах (область III) число фононов в кристалле мало и пробег П. определяется столкновениями П. между собой или с др. дефектами кристалла. В этой области коэф. диффузии П. не зависит от темп-ры и задается концентрацией П.



Зависимость коэффициента диффузии D примесного атома от температуры T .

Все три области наблюдались экспериментально при изучении методом ядерного магнитного резонанса диффузии примесных атомов ^3He в кристалле ^4He . Ширина энергетич. зоны П. оказалась крайне мала: в системе единиц, где $\lambda = 1$, — порядка $10^{-9} - 10^{-4}$ К (для вакансион в ^4He порядка 1 К). В результате энергия упругого взаимодействия П. между собой (каждый П. создаёт вокруг себя поле упругой деформации решетки, с к-рым взаимодействуют др. П.) по величине становится меньше ширины зоны только при очень больших расстояниях между П. При этом сечении σ рассеяния П. друг на друга оказывается аномально большим ($\sigma \sim 100 \text{ \AA}^2$; a — атомный размер), а коэф. диффузии в области III сложным образом зависит от концентрации ^3He .

Лит.: А н д р е е в А. Ф. Диффузия в квантовых кристаллах. *УФН*, 1976, т. 118, с. 251.
 А. Ф. Мельничук.
ПРИМИТИВНАЯ РЕШЕТКА — см. в ст. *Врассе решетки*.

ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАССА — фиктивная масса (или момент инерции), к-рая присоединяется к массе (или моменту инерции) движущегося в жидкости тела для количеств. характеристики инерции окружающей его жидкой среды. При неустановившемся поступат. движении тела (см. *Нестационарное движение*) в идеальной жидкости (в отличие от установившегося движения) возникает сопротивление жидкости, пропорциональное ускорению движения тела и обусловленное увеличением среды, окружающей тело; коэф. пропорциональности и представляет собой П. м. Физ. смысл П. м. заключается в том, что если присоединить к телу, движущемуся в жидкости, дополнит. массу, равную массе жидкости, увлекаемой телом, то закон его движения в жидкости будет таким же, как в пустоте.

Значение П. м. для тел равной формы различно и зависит от ориентации тела относительно направления его движения. Для кругового цилиндра П. м. равна массе жидкости в объёме цилиндра. Для цилиндра, осн. по отношению, имеющим форму эллипса, движущегося в жидкости в направлении, перпендикулярном направ-

лению одной из осей эллипса, $\Pi. м. \mu = \rho l a^2$, где a — длина полуоси эллипса, ρ — плотность жидкости. Т. о., на величину $\Pi. м.$ влияет размер осей, перпендикулярной направлению потока. Для шара $\Pi. м.$ равна половине массы жидкости в объеме шара: $\mu = (2/3)\rho l r^3$, где r — радиус шара. При поступат. движении диска в направлении, перпендикулярном его поверхности, $\mu = (8/3)\rho l r^3$, где r — радиус диска. Присоединенный момент инерции (т. е. коэф. при угл. ускорении в выражении для момента инерц. сил, действующих со стороны жидкости на вращающееся тело) круглого диска относительно осей, совпадающей с одним из диаметров диска, равен $(16/45)\rho l r^5$. Теоретически вычислены $\Pi. м.$ значит. числа контуров в просторастянутых тел: профиля Жуковского, круговой лопатки, прямоугольника, ромба и шестиугольника, «лемета» прямоуг. решетки, эллипсоида, удлиненного тела вращения и т. д. В др. важных случаях $\Pi. м.$ найдены эксперим. путем. Напр., $\Pi. м.$ прямоуг. пластинки с размерами $b \times l$, движущейся в жидкости перпендикулярно своей плоскости, может быть выражена полученной из опытов Флой-

$$\frac{\rho b l^3 \mu^2}{4\sqrt{1-\mu^2}} \left(1 - 0,425 \frac{b l}{b l + \mu}\right)$$

При движении тел в воздухе (снаряд, ракета, самолёт) $\Pi. м.$ мал, и его обычно пренебрегают, но, напр., при нестационарном движении дирижабля необходимо учитывать $\Pi. м.$ Определение $\Pi. м.$ имеет существенное значение при изучении неустановившихся движений тел, полностью погружённых в воду, качки судов, акустики, излучения и т. д. Подсчёты $\Pi. м.$ производятся в предположении, что жидкость липкая вязкости. Обычно пренебрегают и сжимаемостью жидкости. В случае *потенциального течения* несжимаемой идеальной жидкости через $\Pi. м.$ A_{ik} выражают проекции кол-ва движения, момента кол-ва движения и кинетич. энергии Т жидкости. Если q_1, q_2, q_3 — проекция на оси координат вектора скорости движения тела, а q_4, q_5, q_6 — угл. скорости тела относительно осей координат, то $T =$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^6 \sum_{i=1}^6 A_{ik} q_i q_k \cdot \text{Коэф. } A_{ik} \text{ обладают свойством симметрии, т. е. } A_{ik} = A_{ki}, \text{ и поэтому, в самом общем случае поступат. и вращат. движения тела в жидкости, действующие инерции может быть определено с помощью 22 коэф. } \Pi. м.$$

Повятые $\Pi. м.$ обобщено на случай сосудов, наполненных жидкостью, имеющей свободную поверхность; определены $\Pi. м.$ при отрывном обтекании контуров. Для тел, колеблющихся в сжимаемой жидкости, инерц. силы линеино выражаются через ускорения. Коэф. при ускорениях паз. обобщёнными $\Pi. м.$ В случае сжимаемой жидкости свойства симметрии $\Pi. м.$ сохраняются, но сами $\Pi. м.$ зависят, в противоположность случаю несжимаемой жидкости, не только от формы тела и направления движения, но ещё и от частоты колебаний. Наконец, понятие $\Pi. м.$ обобщается и на случай качки корабля на поверхности волнующейся тяжёлой жидкости. В этом случае свойство симметрии $\Pi. м.$ не сохраняется, а сами $\Pi. м.$ существенно зависят от длины и направления набегающих волн и от скорости хода корабля.

Лит.: Ламб Г. Гидродинамика, пер. с англ., М.—Л., 1947; Риван и Б. С., Кредс Р. Л., Присоединенные массы тел различной формы, М., 1947; Седов Л. И., Последние задачи гидродинамики и аэродинамики, 3 изд., М., 1980.

С. Л. Вишневецкий, М. И. Гуревич.

ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ВИХРЬ — условный вихрь, неподвижно связанный с телом (крылом), обтекаемым бевихревым потоком идеальной несжимаемой жидкости. Введён Н. Е. Жуковским как воображаемое «жидкое крыло», ограничительное замкнутое контуром (линейной тока), внутри к-рого происходит движение идеальной жидкости в виде вихря (круговое движение частиц). Циркуляция скорости, создаваемая $\Pi. в.$, равна

циркуляции скорости по контуру, охватывающему действительное обтекаемое крыло, возникновение к-рой в идеальной жидкости связано с невозможностью появления в ней больших отрицат. давлений и растягивающих усилий.

При вычисления *подъёмной силы* крыла бесконечно большого размаха (см. Жуковского теорема) это крыло можно заменить $\Pi. в.$ с прямойлинейной осью, к-рый создаёт в окружающей среде ту же циркуляцию скорости, что и действит. крыло. Итенсивность $\Pi. в.$ (циркуляция скорости по контуру, охватывающему крыло) определяется на основе Чаплыгина — Жуковского постулата.

При решении задач о распределении давлений в аэродинамич. газопотоке по хорде крыла его заменяют системой $\Pi. в.$, непрерывно распределённых по контуру профиля крыла или по ср. линии профиля (в теории



Схема присоединённого и свободных вихрей крыла конечного размаха.

тонкого крыла). Эта система вихрей представляет собой присоединённый вихревой слой крыла. Исходя из граничных условия, чтобы на поверхности крыла скорость потока была направлена по касательной к ней, составляют ур-ние, в к-рое входит погонная циркуляция присоединённого вихревого слоя. Найдя эту циркуляцию, вычисляют по теореме Жуковского погонную нагрузку, к-рая в случае тонкого крыла равна разности между давлением на ниж. и верх. поверхности крыла.

Т. к. внутри жидкости вихри не могут заканчиваться, то в случае крыла конечного размаха $\Pi. в.$ продолжаютс. в окружающей среде в виде свободных вихрей (рис.). Знание вихревой системы крыла позволяет вычислить действующие на него аэродинамич. силы. В частности, от взаимодействия присоединённых и свободных вихрей крыла возникает *индуктивное сопротивление* крыла.

Лит.: Жуковский Н. Е., О присоединённых вихрях, Собр. соч., т. 4, М.—Л., 1949; Голубев В. В., Лекции по теории крыла, М.—Л., 1949; Лойцянский Л. Г., Механика жидкости и газа, 6 изд., М., 1987; Степанов Г. Ю., О некоторых неточности в разъяснениях теории крыла, «Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа», 1975, в. 3, с. 188.

С. Л. Вишневецкий.

ПРИСТОЧНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ — электронная проводимость разреженной замагниченной плазмы поперёк магн. поля, обусловленная столкновениями электронов не с тяжёлыми частицами (атомами, ионами) в объёме, а столкновениями с поверхностями (стенками), пересекающими магн. силовые линии. Проводимость поперёк магн. поля возникает при наличии возмущения дрейфовой скорости частиц. $\Pi. п.$ может быть связана как «диффузионн», так и «квазиизергальным» рассеянием электронов.

Присточная проводимость с диффузионн рассеянием. Если поверхность гладкая (т. е. размер неровности $\delta \ll \lambda_d$ — дебаевского радиуса экранирования) и скорость электронов дрейфа параллельна ей, то $\Pi. п.$ создается те электроны, к-рые «пронизывают» дебаевский слой и диффузно рассеиваются непосредственно на поверхности. Это имеет место, напр., в осесимметричных системах с внешними (полюoidalными) магн. и электрич. полями.

Возникновение «диффузионн» $\Pi. п.$ можно рассмотреть на простой модели (рис. 1, а): плоская поверхность ($y = 0$), дебаевский слой пренебрежимо тонок, магн. поле H однородно и перпендикулярно поверхности, а электрич. поле E в объёме плазмы параллельно

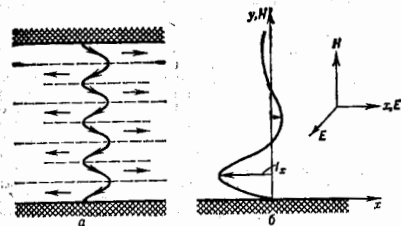


Рис. 1. Взаимодействия электронов с поверхностью: а — токовый слой в идеализированной модели рассеяния моноэнергетических электронов стенкой (кривая со стрелками — проекция траектории движения электрона, отражённого стенкой, на плоскость xy); б — распределение пристеночного тока при наличии разброса скоростей электронов.

поверхности и направлено вдоль оси x . Электроны при падении на стенку полностью теряют скорость. Возвращаясь в объём, они разогнаются в дебаевском слое (скачок потенциала U_D) и приобретают скорость $v_{0y} = \sqrt{2eU_D/m_e}$. Двигаясь далее с такой скоростью в объёмных электрич. и магн. полях, электроны начинают выписывать циклоиду вдоль осей x и z , смещаясь со скоростью v_{0y} вдоль магн. поля. Проекция этого движения на плоскость yz имеет вид, приведённый на рис. 1; объём канала разбивается на систему плоскостных n слоёв с чередующимися противоположными направлениями движения электронов. При этом толщина каждого слоя $h = v_{0y} T_H / 2 = v_{0y} / \omega_H$ (T_H — период продольного вращения). Если в канале укладывается целое число слоёв, то переносимый ток будет равен либо нулю (число слоёв чётное), либо будет максимальным (при нечётном числе слоёв). Отнесённый к 1 см длинн вдоль оси z он равен

$$J_{\text{макс}} = en \int_0^h v_{0y} dy = 2v_{0y} n m_e^2 / H^2 \sim n E / H^2.$$

Поскольку в реальных условиях отражённые электроны не имеют одинаковых скоростей, плоскопараллельные слои имеют разную толщину и вследствие этого разносторонние электроны, находящиеся на одной дистанции от стенки, будут иметь разное направление движения. В результате в плазменном канале оказываются чётко выраженными 2—3 осцилляции (около стенок), а остальные затухают при удалении от них (рис. 1, б).

Пристеночная проводимость с «квазирезонансным» рассеянием реализуется на шероховатой поверхности ($\lambda > r_D$) или на гладкой поверхности, если скорость дрейфа ей не параллельна. Зеркальное отражение электрона от дебаевского скачка потенциала приводит к изменению дрейфовой скорости. В этом случае (в отличие от диффузного) в П. п. втягиваются все электроны, достигающие дебаевского слоя вне зависимости от того, рассеются они на самой поверхности или нет.

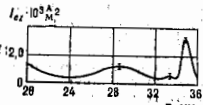
Переход электронов путём рассеяния на стенках является своеобразным обобщением кнудзенсовского течения газа в трубах (см. *Динамика разреженных газов*). Развитие состоит в том, что электрон находится в зл. магн. полях и поэтому между столкновениями двигается не по прямой, а по сложной траектории. Кроме того, при кнудзенсовском течении каждая частица сталкивается со стенкой, тогда как в плазменном объёме может существовать группа электронов, к-рая вообще не достигает стенок, т. к. заперта в объёме полями. У-ние для n -й распределения электронов, рассеиваемых стенкой при отсутствии столкновений в объёме, имеет вид:

$$f_{\text{отр}}(v, x) = \hat{S} k / \text{отр}(v', x') + q(v, x).$$

Здесь $f_{\text{отр}} = v_n f(v, x)$ — распределение по скоростям потока частиц, идущих от стенки, v_n — нормальная составляющая скорости, x — координата точки на поверхности объёма, k — оператор «переноса» частиц от одной точки (x) к другой (x') (в известных E, H полях он определяется из решения ур-ния Власова), \hat{S} — оператор рассеяния частиц на поверхности, q — плотность эмиссии (поглощения) электронов.

Проводимость, очень напоминающая пристеночную, может наблюдаться и на ионах, если повторная ионизация нейтрального атома, возникшего при попадании иона на стенку, происходит на расстояниях меньше ларморовского радиуса.

Рис. 2. Распределение плотности продольного электронного тока $I_{\parallel}(r)$ по радиусу в канале ускорителя с замкнутым дрейфом электронов на расстоянии 13 см от анода (внутренний радиус канала $r = 20$ мм, внешний — 36 мм).



Аналогом П. п. является т. н. *статический скин-эффект*, к-рый наблюдается в охлаждённых до гелиевых темп-р металлах, находящихся во внеш. магн. поле.

Явление П. п. было предсказано А. И. Морозовым и обнаружено экспериментально на *плазменном ускорителе* с замкнутым дрейфом электронов. Он представляет собой цилиндр, канал, перпендикулярно стенкам к-рого создаётся квазирезонансное магн. поле, а вдоль системы между анодом и катодом приложено продольное электрич. поле. Ускоритель работал на Хе и имел характерные параметры: $H_{\text{макс}} \leq 200 \text{ З}$, $U_0 = \approx 200 \text{ В}$, $n_e \leq 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_e \leq 20 \text{ эВ}$, $n_a \sim 10^{13} \text{ см}^{-3}$ при расстоянии между стенками 16 мм и длине канала 40 мм. Радиальное распределение продольного электронного тока, полученное с помощью вонда, имело осциллирующую структуру (рис. 2).

Лит.: Морозов А. И., Эффект пристеночной проводимости в коротко замкнутой плазме, *Ж. прикл. мех. и техн. физ.*, 1968, в. 3, с. 19; Морозов А. И., Шубин А. П., Кинетика электронов в режиме пристеночной проводимости, «Физ. плазмы», 1984, т. 10, в. 6, с. 1283; Буторов А. И., Морозов А. И., Харчевников В. К., Исследование структуры пристеночного слоя с помощью вонда различных размеров, «ЖТФ», 1985, т. 55, в. 4, с. 1072. А. И. Буторов. **ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР** (прицельное расстояние, параметр удара) — в классич. теории рассеяния частиц расстояние между рассеивающим центром и первичным направлением движения рассеивающихся частиц (см. *Рассеяние микрочастиц*).

ПРИЧИННАЯ ФУНКЦИЯ ГРИНА — то же, что *пропагатор*.

ПРИЧИННОСТИ ПРИНЦИП — один из наиб. общих принципов физики, устанавливающий допустимые пределы влияния физ. объектов друг на друга. П. п. запрещает влияние данного события на все прошедшие события («событие-причина предшествует по времени событию-следствию», «будущее не влияет на прошлое»). Более сильный релятивистский П. п. исключает также взаимное влияние событий, разделённых пространственноподобным интервалом, для к-рых сами понятия «раньше», «позже» не абсолютны, а меняются местами с изменением системы отсчёта. Взаимное влияние таких событий было бы возможно лишь с помощью объекта, движущегося со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Поэтому известное утверждение о невозможности сверхсветовых движений в рамках *относительности теории* вытекает именно из релятивистского П. п.

П. п. — эмпирич. постулат, основанный на обобщении данных эксперимента и общетеоретической физики и подтверждающийся без к.-л. исключений в широ-

ком диапазоне масштабов от субъядерных до космологических. Физ. и методологич. смысл П. п. тесно связан с философским понятием *причинности* (взаимной обусловленности, детерминированности последовательности событий): если бы данное событие могло влиять не только на будущее, но и на прошлое, то возникла бы возможность образования замкнутых циклов причинности. Связи, т. е. возможности обратного влияния следствия на породившую его причину вплоть до полного её уничтожения и разрыва причинно-следств. связи (так, путешествие в «машине времени» мог бы уничтожить своего предка в добром возрасте, т. е. саму причину своего появления на свет). Однако с общим понятием причинности согласуется и П. п. с обратным направлением причинно-следств. связи («прошлое не влияет на будущее»). Вопрос о причине совпадения направления этой связи с направлением времени относится к числу нерешенных проблем, связанных с П. п.

Объектом приложения П. п. служит относящаяся к данной физ. системе пара событий, причинно связанных друг с другом (а не являющихся следствиями третьего события), о к-рых известно, какое на них играет роль причина, а какое — следствия (безотносительно к их временному порядку). Для выявления такой пары используется мысленный эксперимент, состоящий в наложении на систему малого возмущения и в регистрации соответствующей реакции системы. При этом событием-причиной служит исходное возмущение при obeyт. условиях, что оно совершенно произвольно способно принимать любые наперед заданные значения и не испытывает обратного влияния со стороны самой системы (примером может служить воздействие внешне по отношению к системе заданного источника). Роль события-следствия играет реакция системы на такое возмущение, т. е. линейное изменение к-л. характеристики системы; ф-ция, осуществляющая такую линейную связь, наз. Φ и к л и е ф — от к л и к а. Напр. применение П. п. в электродинамике материальной среды требует выбора в качестве события-причины — возмущения электрич. индукция, совпадающей с полем внеш. источника, а в качестве события-следствия — соответствующего изменения напряженности электрич. поля (часто практикуемый обратный выбор неправилен, т. к. возмущение напряженности поля включает в себя некорректируемый вклад самой среды). Выбрав указанным способом пару причинно-связанных событий, можно перестроить П. п. в *виде условия* *исчезновения соответствующей ф-ции* отклика при отлнцт. временах, а для результирующего П. п. — *вне полости светового конуса, обращенной в будущее*.

Применения П. п. в аппарате теоретич. физики многочисленны и разнообразны. Он служит средством выбора нач. условий к динамик. уравн-ям, обеспечивая однозначность их решения. Так, при решении *Максвелла уравнений* П. п. позволяет сделать выбор между опережающими и запаздывающими потенциалами в пользу последних. В *квантовой теории поля* (КТП) и *квантовой теории многих частиц* с помощью П. п. устанавливаются правила обхода особенностей *Грина функций*, что делает однозначной технику *Фейнмана диаграмм*.

Наиб. содержит следствия П. п. относятся к теории ф-ций отклика физ. системы, фуре-компонента к-рых по времени зависит от частоты ω , рассматриваемой как комплексная переменная. Из П. п. прямо следует аналитичность ф-ций отклика как ф-ции частоты в верх. полуплоскости ω ($\text{Im} \omega > 0$). Отсюда вытекает *дисперсионные соотношения* для ф-ции отклика, связывающие её дисперсионные (зависимость от частоты) и абсорбционные (поглощение) свойства. При этом запаздывание реакции системы относительно её возмущения приводит к соотношениям, подобным *Краммерса — Кроуна соотношениям*, а результирующий П. п. даёт более общие и ограничит. дисперсионные соотно-

шения, выданные М. А. Леонтовичем и связанные с общ. представлением Йоста — Лемана — Дайсона для матричного элемента запаздывающего коммутатора.

Микроскопич. основу отклика физ. системы составляют последоват. элементарные акты рассеяния носей, осуществляющих её возмущение, на частнах системы. Поэтому П. п. эффективен и применителен к самому акту рассеяния. Дисперсионные соотношения для рассеяния играют здесь особую роль в ядерной физике (накнн и высоких энергий). Особенно они важны для рассеяния сильно взаимодействующих частиц (адронов) — редкий пример точной зависимости между наблюдаемыми величинами (амплитудой упругого рассеяния вперед и полным сечением (*Оптического теорема*)), выведенной без использования к-л. модельных предположений об элементарных частнах (см. также *Дисперсионных соотношений метод*). Вывод дисперсионных соотношений относится к числу наиб. ярких достижений особого аксиоматич. подхода в теории фундам. взаимодействий, испытавшего бурное развитие в 1950—80-х гг. в рамках к-рого П. п. принадлежит конструктивная роль одного из главных (наряду с требованиями теории относительности и квантовой теории) постулатов, лежащих в основе этого подхода (см. *Аксиоматическая квантовая теория поля*).

Понимая перечисленные конкретные приложения П. п. в физике не раз возникало обострение интереса и к более общим проблемам, связанным с П. п. и понятием причинности. В период становления *квантовой механики* широко обсуждался вопрос, противоречит ли детерминизму вероятностное описание микрочастиц. К разрешению этого вопроса привело понимание необходимости отказаться от примитивной детерминизма классич. механики при рассмотрении статист. закономерности микромира. Переход к адекватному описанию последних на языке волновых ф-ций приводит к тому, что в квантовой механике нач. состояние системы полностью определяет (при заданных взаимодействиях) всю последующую её эволюцию.

В 50—80-х гг. трудности КТП стимулировали интерес к возможности нарушения П. п. в области сверхмалых масштабов пространства-времени. Такая возможность связана с тем, что под обходом в формулировке П. п. понимается «точечное» событие, происходящее в данной точке пространства в данный момент времени; соответственно П. п., о к-ром до сих пор шла речь, наз. также в принципе *микроскопической причинности* (см. *Микропричинность*). Между тем ограничения, вытекающие из квантовой теории и теории относительности, делают невозможной физ. реализацию точечного события: любое событие (т. е. любой акт взаимодействия частиц) имеет конечную протяженность в пространстве и времени. Поэтому в области сверхмалых масштабов П. п. теряет свой непосредств. физ. содержание и становится формальным требованием. Это и позволяет говорить о возможности нарушения П. п. «в малом», разумеется, при сохранении его справедливости в больших масштабах пространства-времени. Такой «ослабленный» П. п. наз. в принципе *макроскопической причинности*; его количественной формулировки, адекватно отражающей указанные выше ограничения, ещё нет. Этот принцип лежит в основе многочисл. попыток обобщения КТП, относящихся к *нелокальной квантовой теории поля*.

В кон. 60-х гг. стало общепризнанным, что частная (специальная) теория относительности сама по себе не запрещает движений со сверхсветовой скоростью, и началось подробное обсуждение свойств соответствующих объектов — т. е. *тахионов* (частиц с мнимой массой) и «суперлуксов» (сверхсветовых фоновых и сильно слабой среде). Это стимулировало многочисл. попытки применить сверхсветовой характер движения к выполнению П. п. и привело к более углублённому пониманию проблемы причинности, хотя сколько-нибудь полной явсо-

сти здесь достигнуто не было. С П. п. в совр. физике связаны комплекс сложных и глубоких проблем, к-рые ещё ждут своего решения.

Лит.: Reichenbach H., The philosophy of space and time, N. Y., 1938; Кирьянич Д. А., Савоенов В. Н., Сахаровские движения в специальной теории относительности, 1-й. Физматгизский сборник, 1973, М., 1974; Нуссбаум В. Г., Х. М., Причинность и дисперсионные соотношения, пер. с англ., М., 1976; Кирьянич Д. А., Общие свойства микромеханических функций отклика, «УФН», 1987, т. 152, С. 399, см. также лит. при ст. Квантовая теория поля, Исследования в области теории поля, Д. А. Кирьянич.

ПРИЧИННОСТЬ — философская категория, в самом общем абстрактном смысле выражающая зависимость существования одних фрагментов действительности от существования других её фрагментов. Более конкретного содержания и однозначно определяющего смысла термин «П.» не имеет. Многообразие значений, связанных с этим термином, во многом обусловлено историч. развитием представлений о П. [1, 2, 3, 4, 5] и определяется разл. пониманием конкретного характера зависимости между фрагментами действительности. Это многообразие можно условно упорядочить, располагая разл. понимания П. между предельно узкой (П₁) и предельно широкой (П₂) её трактовками.

Классическая причинность. Понятие П. в узком смысле слова первоначально возникло в связи с практич. деятельностью людей, для неё характерны три признака: 1) временное предшествование причины следствию; 2) одна и та же причина всегда обуславливает одно и то же следствие; 3) причина — активный агент, производящий следствие. Здесь П. понимается как однозначно определяемая необходимая генетич. связь, выражающая представление о порождении одним фрагментом действительности (причиной) другого (следствия). Визуальная связь причины и следствия образует элементарное «ядро причинной цепи событий, к-рая, в принципе, неограниченно может быть продолжена в будущее и протянута в прошлое. Данную простейшую форму П. можно назвать наглядной (или качественной), она достояние сама по себе только на уровне познания единичных явлений и их связей друг с другом. Пока исследуются отд. события и ставится вопрос, от чего они зависят и почему существуют, мы имеем более или менее кофигурные факторы, к-рым вызывают, производят эти события. В этом случае П. лишь качественно характеризует связь явлений, поэтому её наз. качественной, и отличие от П. в количественных физ. теориях, когда состояние системы можно определять строго математически.

Причинность в широком понимании смысла термина понимается как синоним «всемирной связи» — универсального детерминизма, согласно к-рому существование любого фрагмента действительности детерминировано (определяется, обуславливается) другими (в предельно — всеми остальными) её фрагментами, причём не обязательно причинным образом в первом, узком смысле П., а, напр., структурно, телеологически, функционально, статистически, системно и т. д.

Термин «детерминизм» также не имеет однозначно опред. смысла: наряду с предельно широким его толкованием он может употребляться и как синоним П. в узком смысле («лапласовский детерминизм»), поэтому часто понимание выражений, содержащих термин «П.» и «детерминизм», вне достаточно обширного контекста практически невозможно.

Классическая причинность. В совр. естествознании (в первую очередь в физике) сложилось понимание П., занимающее в нек-ром смысле промежуточное положение между крайними её формами П₁ и П₂. Его можно формулировать так: в развитых науч. дисциплинах, достигших высокой степени использования матем. аппарата и дающих открываемым закономерностям матем. формулировку, под П. прежде всего понимается связь состояний во времени, такая, что на основе знания предшествующего состояния системы можно предсказать её последующие состояния [7]. Данную форму П.

можно назвать количественной (теоретической) или (более точно) причинной и остью в физике, т. е. ни в одной др. науке мы не имеем точно формулируемого понятия состояния и, соответственно, количественной П. (Нек-рые авторы считают, что связь состояний не следует рассматривать как причинную связь, однако употребление термина в данном смысле давно стало привычным [7].)

Причинность в фундаментальных динамических теориях. Если в данный момент времени точно известны координаты и в импульсах всех частиц системы, то, согласно классич. механике Ньютона, однозначно определено её состояние. Все процессы сводятся к переходу системы частиц на одно состояние в другое, и наступление данного события — это переход системы в состояние с данными значениями координат и импульсов частиц. Зная характер зависимости сил взаимодействия от координат и скоростей, можно с помощью ур-ний движения классич. механики по состоянию системы в нач. момент времени определить однозначно её состояние в любой последующий момент. Поэтому состояние механич. системы в нач. момент времени (выбор её импульсов и координат) наряду с известным законом взаимодействия частиц может рассматриваться как причина, а состояние в последующий момент — как следствие. В этом суть представлений о динамической, или однозначной, П. в классич. физике — суть классич. детерминизма.

Сформулированная на основе механики Ньютона однозначная П. характерна для динамич. закономерностей любого вида. В частности, открытие Дж. К. Максвеллом (J. C. Maxwell) системы ур-ний для ал.-матри. поля и в малейшей степени не изменило представлений об однозначной П. Как и механика Ньютона, теория Максвелла позволяет по точно фиксированным значениям величин (напряжённостей электр. и магн. полей) в нач. момент времени и заданным граничным условиям однозначно найти значения этих величин в последующие моменты. Состояние системы определяют новые величин (характеристики полей вместо координат и импульсов), но в остальном всё остаётся неизменным [8].

Такая же ситуация наблюдается во всех фундам. теориях динамич. типа, в к-рых состояние системы характеризуется набором тех или иных физ. величин.

Причинность в фундаментальных статистических теориях. Уже в рамках классич. физики была построена теория, хотя и не разрушавшая концепцию классич. детерминизма, но в значит. мере подорвавшая веру в его абс. характер. Речь идёт о классич. статистич. механике.

В статистич. механике состояние системы характеризуется не набором точных значений координат и импульсов всех частиц, а ψ -ф-цией распределения, определяющей вероятность того, что координаты и импульсы частиц системы имеют опред. значения, т. е. то, как часто в ансамбле тождественных систем встречается разл. распределение значений координат и импульсов частиц. По ф-ции распределения в данный момент времени (при известной энергии взаимодействия) можно однозначно найти вероятность появления опред. значений координат и импульсов частиц в любой последующий момент времени; они рассматриваются как случайные величины, не определяемые однозначно макроскопич. условиями (тем-рой, давлением, объёмом и т. д.), в к-рых находится система. Т. о., в этом случае причиной связям вероятности координат и импульсов. Это новая форма П. — в е р о я т н о с т и а и п р и ч и н о с т ь, понимание к-рой в осн. остаётся прежним: состояние системы в данный момент однозначно определяется состоянием системы в предшествующий момент, однако способ описания состояния становится новым, вероятностным.

Вероятностная форма П. характерна и для любой др. статистич. теории, в частности для микроско-

пич. электродинамики. Представляет интерес точеч. поведения траекторий не-р-ных динамич. систем в связи с последующим турбулентности. Несмотря на то, что решения у-р-ний полностью определяются нач. данными, они с течением времени меняются чрезвычайно нерегулярным образом. Малые отклонения нач. условий вызывают большие изменения в поведении системы через опред. время. Для наблюдателя картина поведения траекторий системы выглядит полностью хаотичной — т. н. динамический хаос.

Причинность в квантовой механике. До появления квантовой механики считали, что в основе мироздания лежат динамич. законы с их однозначной П. Несмотря на то, что незначит. изменения нач. условий в сложных системах приводили к сильным изменениям их конечных состояний, так что наличие малых ошибок в нач. условиях было равносильно полному незнакомо дальнейшего поведения системы, всё же считали, что вторжение этих ошибок имеет практическое, а не принципиальное значение. Полагали, что классич. детерминизм в каком-то виде сохраняется.

После открытия статистич. характера законов движения отд. микрочастиц и создания квантовой механики оказалось, что вероятностная П. может существовать сама по себе, без стоицей за ней однозначной динамич. П., и является основной, а однозначная динамич. П. — её частным случаем.

В квантовой механике состояние системы полностью характеризуется волновой ф-цией $\Psi(x, y, z, t)$, определяющей распределение вероятностей для любой ф-цы. величины. Эта ф-ция удовлетворяет Шрёдингера уравнению и является амплитудой вероятности. Если известна волновая ф-ция в нач. момент времени t_0 и оператор Гамильтона системы, определяющий энергетич. взаимодействия частей, то у-р-ние Шрёдингера позволяет однозначно найти волновую ф-цию в произвольный последующий момент времени t . Вследствие этого нач. состояние, $\Psi(t_0)$, вместе с опред. законом взаимодействия частей можно рассматривать как причину, а состояние в последующий момент, $\Psi(t)$, — как следствие.

Т. о., понятие динамич. П. в квантовой механике неприменимо, но вероятностная П. здесь справедлива в той же мере, что и для объектов классич. статистич. теории. Напр., зная нач. состояние электронов, издающих на дифракц. решётку, заданное в виде плоской волны де Бройля (состояние с опред. импульсом), можно однозначно предсказать распределение электронов на экране — дифракц. картину. Вид дифракц. картины, образованной частицами и заданным импульсом, определяется однозначно, но поведение отд. электронов остается случайным. Электроны в одном и том же состоянии попадают после дифракция на разл. участки экрана. Уточнить к.-л. образом нач. состояние частицы с тем, чтобы можно было проследить в деталях за её движением и предсказать, куда она попадет после рассеяния на дифракц. решётке, принципиально невозможно. Любая попытка фиксации координат частиц до дифракция так изменит их импульсы, что вся дифракц. картина окажется смазанной.

Особенно отчетливо статистич. характер явлений микромира обнаруживается при распадах радиоакт. ядер и нестабильных элементарных частиц.

Отметим, что точно формулируемая количественная (теоретическая) вероятностная П. в классич. статистич. теориях не исчерпывает П. полностью. Кроме того, сохраняется понятие качественной (или наглядной) П. в том смысле, что те или иные случайные значения координат, импульсов и др. величин причинно обусловлены. Напр., причиной очередного случайного броска броуновской частицы в опред. направлении является нескомпенсиров. удары молекул о частицу с одной стороны.

Нельзя заранее полностью исключить возможность того, что и в квантовой области качественная П. всё

же способна объяснить детали того или иного явления микрообъекта. Определ. отклонение электрона при дифракции, распад частицы в данный момент и т. д. имеют свои причины. Так, в частности, взаимодействие с физ. вакуумом можно рассматривать как проявление универс. связи микрообъектов, исключая, щей возможность их полной индивидуализации. Это взаимодействие статистич. характера, возможно, и обуславливает детали поведения отд. микрообъектов. Но отсюда, конечно, ни в коем случае не вытекает, что для микрообъектов возможны законы динамич. типа.

В квантовой теории поля принцип П. в явной форме используется в качестве активного начала при развитии теории (см. *Причинность принципл*).

- Лит.: 1) Г о с б е т., Избр. произведения, пер. с лат. и англ., т. 1, М., 1964; 2) Л е в и н ц Г. В., Сов. т. 1, М., 1962; 3) М а х Э., Анализ ощущений и отношение физического и психическому, пер. с нем., 2 изд., М., 1908; 4) Р а с с е л Б., Человеческое познание. Его сфера и границы, пер. с англ., М., 1957; 5) В у н г е М., Причинность, пер. с англ., М., 1962; 6) Философия естествознания, в. 1, М., 1968; 7) С в е т и н х о в Г. А., Причинность и связь состояний в физике, М., 1971; 8) М а к ш е в Г. Я., Динамические и статистические закономерности в физике, М., 1973. Г. Л. Малинин.

ПРИЗЛЕКТРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — процессы в газовых разредах в неоднородной по концентрации, темп-ре и др. параметрам плазме, заключённой между электродом и почти однородной плазмой. В противоположность однородному *положительному столбу* плазмы, где ток протекает под действием электрич. поля, в приэлектродных областях авачит. роль играют *переноса процесс* заряд. частиц за счёт диффузии и под действием градиента темп-ры. В непосредств. близости от электрода распределения электронов и ионов по скоростям, как правило, отличаются от распределения Максвелла.

Сложность П. я. определяется не только разнообразием условий, в к-рых они протекают, но и необходимостью во мн. случаях рассматривать явления как вблизи электрода, так и на самом электроде при взаимном влиянии их друг на друга. Это обстоятельство характеризует состав и свойства приэлектродной плазмы. Так, напр., существование и самоподдержание вакуумного дугового разряда определяются образованием катодных пятен и вращением материала катода.

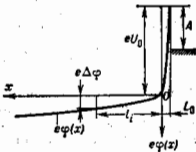
В сильноточных разрезах с термомиссионным катодом и сильноточных дуговых разрезах вдали от электрода устанавливается не только почти однородное, но также и почти равновесное состояние либо для всей плазмы в целом, либо в отдельности для электронов и тяжёлой компоненты (атомов и ионов). В этом случае под П. я. понимают явления в области между электродом и почти равновесной плазмой, в к-рой последовательно релаксируют приэлектродные возмущения. В этой области устанавливаются *квазиравновесность* плазмы, максвелловские ф-ции распределения заряд. частиц, *ионизационное равновесие*, выравниваются темп-ры электронов и тяжёлой компоненты плазмы. Релаксация приэлектродных возмущений происходит на определённых характерных длинах (длина свободного пробега, длина установления квазиравновесности и т. п.), к-рые можно рассмотреть на примере плазмы с достаточно большой концентрацией электронов, резонирующей, напр., в сильноточных разрезах.

Ленгмюровский слой. Ионный ток на границе плазма — электрод. Характерной длиной установления квазиравновесности термодинамически равновесной плазмы является *дебаевский радиус экранирования* $r_D = \sqrt{kT/4\pi n e^2}$, где n и T — концентрация и темп-ра невозмущённой плазмы. В отсутствие равновесия, при протекании тока, приэлектродный слой протрагированного заряда расширяется, образуя т. н. *ленгмюровую* в с к у ю оболочку, протяжённость к-рой L_0 в случае непиттмурующего электрода (при достаточно большом падении напряжения U_0 в слое $(U_0 \gg kT)$ может быть оценена из закона 3/2 Ленгмюра:

$$j = \frac{1}{9\pi} \sqrt{\frac{2eU_0}{m_e L_0}} \quad (1)$$

где j — плотность тока из плазмы на электрод, m_e — масса заряж. частиц, переносчиков ток. Выражение (1) справедливо, когда длина свободного пробега заряж. частиц превышает L_0 . В случае контакта отрицательно заряженного электрода с плазмой на электрод течёт ток и заряд электрода компенсируется зарядом ионов, заполняющих лентгморовскую оболочку толщиной l_0 . Ионы, входящие в лентгморовскую оболочку, должны быть предельно ускорены так, чтобы их скорость v_0 на границе оболочки удовлетворяла условию $v_0 \geq \sqrt{kT_e/m_i}$ (т. н. критерий Бомба). Точку, в к-рой становится скорость $v_0 = \sqrt{kT_e/m_i}$, условно считают границей, отделяющей квазинейтральную плазму от лентгморовского слоя. Т. к. обычно $T_e \gg T_i$, то в квазинейтральной плазме на расстоянии порядка длины свободного пробега иона λ_i существует сильное для ионов электрич. поле, обеспечивающее необходимое ускорение ионов до энергий $\sim kT_e$ (рис. 1).

Рис. 1. Потенциальная диаграмма на границе плазмы с отрицательно заряженным электродом: А — работа выхода, $\phi(x)$ — электростатический потенциал, $\psi(x)$ — электростатический потенциал, ψ_0 — разность потенциалов на границе квазинейтральной плазмы с лентгморовской оболочкой.



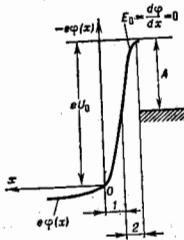
При этом плотность ионного тока на электрод $j_i \approx en\sqrt{kT_e/m_i}$, где n — концентрация ионов на границе квазинейтральной плазмы. Протяжённость лентгморовской оболочки $L_0 \sim r_D(T_e)(eU_0/kT_e)^{1/2}$.

Если отрицат. электрод является эмиттером электронов, то становится существенной напряжённость электр. поля E_0 на поверхности электрода, определяющая величину Шоттки эффекта:

$$E_0 = 8\pi\sqrt{2m_i}U_0/e \left(j_0 - \sqrt{m_i/m_e} j_e^{(0)} \right) \quad (2)$$

где $j_e^{(0)}$ — плотность тока эмиссии катода. При $j_e^{(0)} = \sqrt{m_i/m_e} j_i$ электр. поле $E_0 = 0$ и лентгморовская оболочка представляет собой двойной электрический слой ионов и электронов, в к-ром пространственный заряд плазменных ионов компенсируется зарядом катодных электронов (область 2, рис. 2). При эмиссионном токе $j_e^{(0)} > \sqrt{m_i/m_e} j_i$ электр. поле на катоде становится тормозящим для катодных электронов и у катода возникает минимум потенциала — виртуальный катод, увеличивающий эфф. работу выхода катода.

Рис. 2. Возникновение виртуального катода: 1 — область, где преобладают плазменные ионы; 2 — область, где преобладают катодные электроны.



Величина мин. потенциала такова, что эфф. эмиссия электронов с катода в плазму остаётся на уровне $j_e^{(0)} = \sqrt{m_i/m_e} j_i$.

Выражения для L_0 , E_0 и $j_e^{(0)}$ справедливы лишь при весьма больших значениях eU_0/kT_e , т. к. поправки к этим выражениям $\sim \sqrt{kT_e/eU_0}$. Образование виртуального катода обнаруживается экспериментально в разрядах с термостатическим катодом по резкому ограничению электронной эмиссии с катода в плазму при увеличении темп-ры катода.

Электронный ток на границе плазма — электрод. Функции распределения. Следующей характерной длиной является длина свободного пробега заряж. частиц. На длине свободного пробега понов l_1 в квазинейтральной плазме формируются сильно анизотропное и ускоренное до энергий $\sim kT_e$ распределение ионов. На длине свободного пробега электронов l_e формируются их угл. распределение, к-рое на границе с отрицательно заряженным электродом анизотропно, причём величина анизотропии определяется отклонением eU_0/kT_e . Анизотропия уменьшается при увеличении eU_0/kT_e и при $eU_0/kT_e \gg 1$, когда электроны покидают плазму в основном в пределах узкого телесного угла $\sim kT_e/eU_0$, анизотропия их ф-ции распределения уже перестаёт сказываться на величине тока. Ф-ция распределения электронов в плазме перед задерживающим потенциальным барьером определена для произвольных значений eU_0/kT_e из решения кинетического уравнения Больцмана.

При удалении от электрода ф-ция распределения заряж. частиц изотропизируется. Обычно плазма в приэлектродном слое ионизована слабо, и изотропизация происходит при столкновении заряж. частиц с нейтральными. Столкновения ионов с нейтралами, близкими по массе к m_i , приводят не только к изотропизации, но и к образованию максвелловского распределения для ионов с темп-рой T_i' , совпадающей с темп-рой нейтралов T_n .

Установление максвелловского распределения для электронов в сильноточных разрядах происходит, как правило, за счёт межэлектронных столкновений. Вследствие затруднённого обмена энергией между электронами и тяжёлой компонентой темп-ра электронов T_e в приэлектродном слое отличается от T_n , обычно $T_e > T_n$. В слабоионизов. плазме длина, на к-рой устанавливается максвелловское распределение для электронов, обычно порядка длины релаксации энергии $L_E = \sqrt{D_e(\theta) \tau_E(\theta)}$, где $D_e \rightarrow$ коэф. диффузии электронов, $\tau_E = m_i^2 \nu_i^2 / 2^{1/2} k_e \Lambda n$ — время релаксации энергии электронов, Λ — кулоновский логарифм, $k_e = m_e^2 / 2$ — кинетич. энергия электрода. L_E увеличивается с увеличением θ и для быстрых электронов $\theta \approx eU_0 \approx eU_0$ член $L_E \gg l_e$. В этом случае ф-ция распределения электронов по энергиям $f_e(\theta)$ в приэлектродном слое может существенно отличаться от распределения Максвелла. Поскольку ток на границе плазма — электрод переносится исключительно быстрыми электронами с $\theta \geq eU_0$, то максвелловская ф-ция распределения влияет на величину тока. Если электрод является поглощающей стенкой, то эмиссия электронов из плазмы на электрод приводит к обеднению быстрыми электронами и к соответствующему уменьшению тока. При наличии эмиссии электронов с электрода часть упруго рассеянных в плазме электронов возвращается на эмиттер и поток поступающих в плазму электронов тоже уменьшается. При учёте обоих эффектов ток на контакте плазмы с катодом

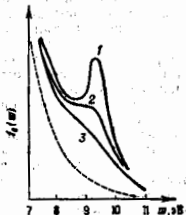
$$j_e = j_e^{(0)} [1 - r_1(T_n, T_e)] - \frac{1}{4} e n v_0 \exp(-eU_0/kT_e) [1 - r_1(T_e)],$$

здесь T_e — темп-ра катода, r_1 и r_2 — кинетич. коэф. отражения. При большой величине r_1 , когда $1 - r_1 \ll 1$, имеет место соотношение:

$$1 - f_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{eU_0}{kT_e} \right)^{1/2} \frac{L_p}{L_e} \frac{L_e}{L_e} \frac{L_e}{L_e}$$

Из соотношения детального равновесия между прямыми и обратными потоками при $T_k = T_e$ и $f_e^{(0)} = 1/2 \nu_{eV} \times \text{хехр}(-eU_0/kT_e)$ следует, что $f_1(T_e, T_e) = f_2(T_e)$. За счёт парных столкновений быстрых электронов катодной эмиссии с массой тепловых электронов плазмы происходит релаксация энергии быстрых электронов и нагрев тепловых электронов; им передаётся энергия $f_2 U_0$, полученная ускоренными катодным пучком в лентированной оболочке. Приведённые выше выражения для L_p и f_e справедливы при $L_p \gg L_e$, когда релаксация энергии предшествует изотропизации быстрых электронов. Для этих условий создана теория релаксации электронных пучков в плазме; типичные расчётные ф-ция распределения $f(x)$ при $r_1, r_2 \ll 1$ приведены на рис. 3; $\omega' = m_e v^2 / 2 - \exp(x) -$ полная энергия электрона. За ноль отсчёта потенциала $\varphi(x)$, как и выше, принят потенциал плазмы на границе с лентированной оболочкой. Ф-ция распределения на этой границе резко немасвелловская (кривая 1) за счёт инжекции в плазму быстрых электронов катодной эмиссии. С удалением от катода эта немасвелловность уменьшается (кривые 2, 3 на рис. 3).

Рис. 3. Функция распределения электронов в прикатодном слое водородной плазмы (при давлении $P_H = 10$ Тор, $f_e^{(0)} = 30$ А/см², $U_0 = 8$ В; степень ионизации плазмы $\beta_e \approx 2 \cdot 10^{-4}$); 1 — $f = 0$ (граница плазмы с лентированной оболочкой); 2 — $x = 0, 1 L_p$; 3 — $x = 0, 25 L_p$ ($L_p \approx 0, 025$ см; пунктир — распределение Максвелла).



В случае $L_p \leq L_e$ в релаксации катодного пучка электронов существен роль могут играть коллективные процессы, в частности лентированные волны.

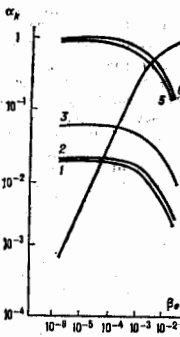


Рис. 4. Доли энергии катодного пучка, вкладываемые в различные виды потерь (1 — 6) при столкновении в прикатодном слое водородной плазмы, в зависимости от степени ионизации β_e при $r_1 = 10$ Тор, $U_0 = 10$ В.

Энергия катодного пучка расходуется не только на нагрев электронного газа в прикатодном слое, но

также на возбуждение электронных и колебат. уровни молекул в соответствующее увеличение скорости джоульевой молекулы. На рис. 4 изображены доли энергии α_k ($k = 1 - 6$), теряемые пучком при столкновении на границе лентированного слоя с плазмой молекулярного водорода, в зависимости от степени ионизации β_e плазмы в приэлектродном слое; кривые 1 — 6 соответствуют потерям энергии при упругих столкновениях, на возбуждение вращений, колебаний молекулы, на нагрев тепловых электронов, на прямую диссоциацию и суммарные потери энергии на возбуждение низко расположенных электронных состояний молекул водорода. Как видно из рис. 4, соотношение между разл. механизмами релаксации энергии меняется при изменении степени ионизации плазмы.

Влияние магнитного поля на приэлектродные процессы в осн. сводится к уменьшению величин тока. Наиб. сильно это влияние проявляется, когда магн. поле H перпендикулярно тону, т. е. параллельно поверхности электрода. Магн. поле изменяет траекторию электрона, вылетающего с катода (или идущего из плазмы на катод), заворачивая его вокруг кривой линии, так что он может вернуться назад на катод (или в плазму). На контакте плазмы с эмиттирующим электродом в поперечном магн. поле ток записывается в виде

$$j_e = \left[j_e^{(0)} - \frac{1}{4} e n \bar{v}_e \exp(-eU_0/kT_e) \right] \chi_{\text{ли}}(\beta),$$

где ф-ция $\chi_{\text{ли}}(\beta)$ описывает уменьшение тока ($\chi_{\text{ли}} < 1$), $\beta = \omega \tau_e$, $\omega = eH/m_e c$ — циклотронная частота, τ_e — время релаксации электронов по импульсу. Ф-ция $\chi_{\text{ли}}(\beta)$ одинакова как для тока электронной эмиссии с катода, так и для обратного тока электронов из плазмы на катод. Явный вид зависимости $\chi_{\text{ли}}(\beta)$ просто определить при $eU_0/kT_e \gg 1$, т. е. когда электроны вылетают с катода в пределах узкого телесного угла. В этом случае траектория электрона практически совпадает с полукругом с радиусом $\rho_c = cm_e/v_e H$. Вероятность того, что электрон не вернется на катод обратно, а, испытав рассеяние, останется в плазме, равна

$$\chi_{\text{ли}}(\beta) = 1 - \exp(-\pi \rho_c / l_e) = 1 - \exp(-\pi / \beta),$$

где $l_e = \nu_e \tau_e$. Расчёт показывает, что $\chi_{\text{ли}}$ слабо зависит от eU_0/kT_e , поэтому приведённое выражение для $\chi_{\text{ли}}(\beta)$ справедливо практически при любых eU_0/kT_e . В сильных магн. полях, когда $\beta \gg 1$, $\chi_{\text{ли}}(\beta) \sim 1/\beta$, а ток в приэлектродном слое $j_e \sim 1/\omega \tau_e$, т. е. время как в объёме плазмы в сильных магн. полях $j_e \sim 1/(\omega \tau_e)^2$.

Ионизация атомов и рекомбинация ионов в приэлектродном слое. Длина, на к-рой в приэлектродном слое слабоионизов. плазмы устанавливается иониз.-рекомбиз. равновесие, обычно наз. для и о и н и з а д и L_i , хотя более правильное название — «длина рекомбинация», т. к. L_i характеризует собой расстояние, с к-рого ион, не рекомбинируя, может уйти из плазмы на электрод. На расстоянии от электрода, существенно превышающем L_i , ионизация локально уравнивается рекомбинацией. Если в процессах ионизации и рекомбинации излучение не играет существенной роли, а ф-ция распределения электронов максвелловская, то ионизационное равновесие соответствует равновесию, описываемому Саха ф-цией с электронной темп-рой T_e . Вблизи электрода на расстоянии $\leq L_i$ плазма обеднена заряд. частицами. Ионный ток из лева-зад.-равновесной плазмы на отрицат. электрод равен

$$j_i = D_i (1 + T_e/T) n(T_e) \psi(\beta_e, T_e/T) / L_i,$$

где $L_i = \sqrt{2D_i(1 + T_e/T) N_A \bar{v}_e \sigma_i(T_e)}$, D_i — коэф. диффузии ионов, N_A — концентрация атомов на границе слабоионизов. плазмы с электродом, $n(T_e)$ — концентрация плазмы в области иониз.-равновесия, $\sigma_i(T_e)$ — зфф. сечение ионизации атома электронным

ударом; ψ — ф-ция, слабо отличающаяся от 1, при ее slightном большем отношении $T_e/T(0,95 \leq \psi \leq 1,2$ при $1 \leq T_e/T \leq 10$). Полученная зависимость фонового тока j_0 от параметров плазмы проверялась экспериментально с помощью зондовых и спектральных измерений наиб. точно в низковольтном дуговом разряде. Приведенные выше зависимости для j_0 и L_1 справедливы при $L_1 \gg l_1$ (l_1 — длина свободного пробега иона в нейтральных атомах), т. е. когда плазма в приэлектродном слое слабо ионизована. В противоположном предельном случае ($L_1 < l_1$) L_1 теряет смысл, т. к. установление ионизац. равновесия происходит на расстоянии от электрода, меньшем или сравнимом с l_1 . На таком расстоянии движение ионов не описывается электроду нельзя описывать в терминах диффузии или подвижности. В этом случае ф-ца. смысла имеет величина $L_1 = v_0/n_0\sigma_e(T_e)$ — длина, на к-рой ионизуются десорбирующиеся с поверхности электрода атомы ($v_0 = \sqrt{2kT_e/m_a}$ — ср. скорость десорбирующихся атомов). L_1 должна быть меньше l_1 — длины свободного пробега десорбирующегося атома, чтобы атом ионизовался прежде, чем столкнется с ионом. В этом случае фонный ток из плазмы на электрод $j_0 \sim en\sqrt{kT_e/m_e}$, где n — концентрация плазмы на границе с легированной оболочкой. На рис. 5 приведена эксперим. зависимость

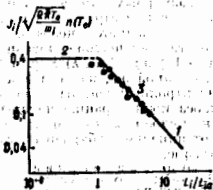


Рис. 5. Зависимость фонового тока от равновесной частоты низковольтной плазмы на электрод от L_1/l_1 ; 1 — расчет для $L_1/l_1 \gg 1$; 2 — для $L_1/l_1 < 1$; 3 — результаты экспериментов в искровом дуговом разряде в Ва.

мость j_0 на равновесной частично ионизованной плазме на электрод как ф-ция отношения L_1/l_1 (l_1 — длина свободного пробега иона в атомах). При малых и больших значениях L_1/l_1 эксперим. результаты совпадают с предельными выражениями для j_0 . В приведенном выше рассмотрении предполагалось, что протяженность области ионизации L_1 превышает длину L_g установления максвелловского распределения электронов. Если $L_1 \leq L_g$, на скорость ионизации в приэлектродном слое существенно влияет неравновесность ф-ции распределения электронов. Вблизи катода это приводит к увеличению скорости ионизации вследствие увеличения частоты ударов первого рода и актов прямой ионизации электронами ударом за счёт появления в плазме несравненно быстрых электронов катодной эмиссии.

В плазме молекулярных газов явления в приэлектродном ионизац.-рекомбинац. слое усложняются вследствие появления молекулярных ионов. При достаточно большом давлении плазмобразующего вещества и низкой темп-ре электрода молекулярные ионы возникают в приэлектродных слоях даже в тех случаях, когда в осн. объёме плазмы они диссоциированы. Каналы рождения и гибели молекулярных ионов многообразны: конверсия атомарных ионов в молекулярные; ассоциативная ионизация, диссоциация, диссоциативная рекомбинация и др. Плазма, образованная молекулярными ионами, вследствие большой скорости рекомбинации обычно находится в состоянии ионизац.-рекомбинац. равновесия, а концентрация такой плазмы мала по сравнению с концентрацией плазмы в осн. объёме. Поэтому возникновение молекулярных ионов в холодных приэлектродных слоях приводит к уменьшению концент-

рации плазмы, а следовательно, и величиним фонного тока, отводимого на плазму на электрод.

Выравнивание температур компонентов плазмы в приэлектродном слое. Передача энергии от электронов атомам и ионам приводит к разогреву тёмной компоненты и к выравниванию темп-р T_e и T_a . Такая ситуация реализуется, напр., в дуговых разрядах, горющих при атмосферном и более высоком давлении. Но в приэлектродном слое темп-ра T_e тёмной компоненты неизменно, а тепло, выделяемое в тёмной компоненте за счёт разности темп-р $T_e - T_a$, отводится потоком теплопроводности от тёмной компоненты на электрод. Протяжённость приэлектродной области понижения темп-ры — парадокс длины температурной релаксации L_T , к-рая в слабоионизов. плазме атомарного газа равна $L_T \sim (\frac{m_a n_a m_e n_e}{m_e n_e})^{1/2}$, где κ_a — теплопроводность атомов, $\tau = \tau_{ea} \tau_{ei} / (\tau_{ea} + \tau_{ei})$ — вф-ф. время релаксации электронов по импульсу при рассеянии на атомах и ионах. В плазме атомарных газов обычно $L_T > L_1$; в плазме молекулярных газов длина L_T существенно сокращается вследствие возбуждения колебаний и вращений молекул электронными ударами с последующей передачей колеб. и вращ. энергии на поступат. степени свободы. Для определения хода темп-ры T_e в приэлектродном слое нужно совместно с ур-ниями теплопроводности решать систему ур-ний колеб. кинетики для молекул. При грубых оценках отношение m_e/m_a в выражении для L_T заменяют на δ ($\delta \gg m_e/m_a$). Здесь δ — доля энергии, теряемая электроном при столкновении с молекулой, к-рая известна в ряде случаев по результатам расчётов и экспериментов.

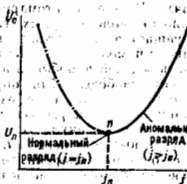
Катодные пятна. В дуговых и искровых разрядах с холодным катодом на поверхности катода образуются катодные пятна — сильно разогретые области размерами 10^{-2} — 10^{-4} см, и к-рым принадлежит яркое свечение плазмы, состоящая полностью или частично из материала катода. Катодное пятно перемещается по поверхности и является «источником» высокоскоростных струй плазмы. Обычно горение дуги начинается с появления быстроперемещающихся пятен (скорость $\sim 10^8$ — 10^6 см/с), к-рые затем переходят в медленноперемещающиеся пятна (скорость 10 — 10^2 см/с). В катодных пятнах катодное падение напряжения обычно имеет величину ~ 10 — 20 В, ток на одно пятно порядка десятков сотен А.

Принадлежащие явления в дуговых разрядах значительно менее изучены, чем процессам в прикатодной области. В дуговых разрядах низкого и ср. давления ($p < 4$ атм.) переход от распределённого по аноду разряда к контраградианному с дуговым эрозивным пятном происходит, когда режим горения дуги с задерживающим электроны анодным падением напряжения переходит в режим с ускоряющим электроны анодным падением. Образование анодного пятна сопровождается мошнющей материалу анода, увеличением концентрации плазмы в прианодной области и тока на анод. Такой процесс может быть определяющим и для др. сильноточных дуговых разрядов.

Приэлектродные явления в тесном разряде. В этом типе разряда катодная область вымощена между катодом и положительным столбом и состоит из анодова тёмного пространства, катодного свечения и катодного тёмного пространства, область отрабат. свечения и фарадеева тёмного пространства. Протяжённость тока на катоде при тесном разряде зависит от рода газа, его давления и материала катода. При изменении разрядного тока меняется только площадь токового пятна на катоде, а катодное падение напряжения U_c и толщина катодного слоя остаются неизменными (нормальный тлеющий разряд). В анодном тлеющем разряде, когда вся площадь катода занята током, катодное падение напряжения и плотность тока увеличиваются с увеличением тока разряда. В тлеющем разряде осн. падение напряжения сосредоточено между катодом и отрабат. свечением, здесь преобладает ионный прост-

равно: заряд, а электрич. поле уменьшается примерно по линейному закону от поверхности катода до границы отрицат. свечения. В области отрицат. свечения образуется квазиравновесная плазма, а электр. поле близко к нулю; в дальнейшем оно снова увеличивается и выходит из кат. области. В нормальном тлеющем разряде катодное падение напряжения составляет почти V_c . Ток в тёмном катодном пространстве и в более близких к катоду областях переносится в осн. ионами, движущимися к катоду. Им сопутствует поток быстрых атомов, образующихся в результате *перезарядки ионов* на атомах газа. Ионы и быстрые атомы выбивают с поверхности катода электроны, необходимые для поддержания разряда, и являются причиной катодного распыления. Теоретич. вид вольт-амперной характеристики прикатодного слоя в тлеющем разряде приведён на рис. 6, где j_n и U_n — т. н. нормальные

Рис. 6. Расчётная вольт-амперная характеристика катодного слоя тлеющего разряда; отрицательная кривая — несуществующая ветвь; n — точка, соответствующая нормальному тлеющему разряду.



плотность тока и падение напряжения. Правая ветвь кривой $U_n(j)$ описывает аномальный тлеющий разряд; левая ветвь невозможна и не реализуется, реально ей соответствует нормальный тлеющий разряд $U_c = U_n$ и $j = j_n$.

Принадлежащие ионам в тлеющем разряде ионы значительно меньше, чем прикатодные. В ряде случаев тлеющий разряд в прикатодной области также контролирован. Величина и знак падения напряжения в прикатодной области зависит от тока разряда: обычно при малых токах анодное падение напряжения укорачивает ослепительный столбик, а при больших токах — терминирует. При укорачивании анодного падения прикатодная область состоит из анодного тёмного пространства, прилегающего к положит. столбу, и анодного свечения, прилегающего к аноду.

Приэлектродные процессы в движущейся плазме связаны с пограничными слоями, образующимися при обтекании плазмой электрода. Наиб. интерес представляет обтекание *квазиравновесн.* электрода. В этом случае у пограничного слоя на поверхности образуется электр. пограничный слой, в пределах которого происходит уменьшение концентрации плазмы вследствие отвода ионов на электрод. Структура пограничного слоя в слабоионизованной плазме определяется соотношением между 4 характерными линейными масштабами: толщиной *дебровской* оболочки L_D , поперечными размерами гравитационн. слоя $\delta_g = L \sqrt{R_g}$, электр. слоя $\delta_e = L \sqrt{R_e}$ и *погранич.-рекомбинан.* слоя L_1 (здесь $L = \lambda$ — длина отбрасываем. пластины; $R_g = \sqrt{V_c} L / \nu$ и $R_e = V_c L / D_1 (1 + T_e/T_c)$ — соответственно гравитационн. и электр. *Рейнольдс* число, V_c — газодинамич. скорость невозмущённого потока; ν — кинематич. вязкость газа, D_1 — коэф. диффузии ионов). Рис. 7 иллюстрирует образование пограничных слоев при обтекании плоского электрода достаточно плотной плазмой, для к-рой длина свободного пробега λ — размеров электрода L и толщины пограничных слоев, так что $L_0 \ll L \ll \delta_g, \delta_e, L_1$. При $L_1 \gg \delta_e, \delta_g$ генерация ионов в пределах пограничного слоя несущественна, у электрода образуется электр. пограничный слой, подобный газодинамическому. Ионы поставляются в этот слой вместе с потоком ионов, газа, т. е. конвективным

путём, и отводятся на электрод под действием электрич. поля и за счёт диффузии (рис. 7, а). При $L_1 \ll \delta_e, \delta_g$ в области плазмы, прилегающей к электроду, образуется практически однородный по длине пластины попереч.-рекомбинан. пограничный слой (рис. 7, б). В этом случае генерация ионов в приэлектродном слое и отвод их на электрод происходит так же, как и в покоящейся плазме. Полный ионный ток, отводимый из плазмы

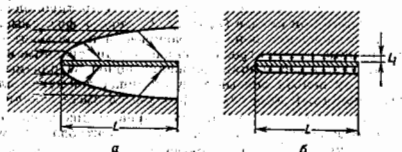


Рис. 7. Плазма в пограничных слоях при различных соотношениях длины L_e и толщины δ_e электродного пограничного слоя: а — $L_1 \gg \delta_e, \delta_g$; б — $L_1 \ll \delta_e, \delta_g$. Стрелками обозначены линии тока ионов из невозмущённой плазмы на электрод.

на отрицательно заряженный электрод длиной L единичной толщины может быть представлен в виде $I_1 = \epsilon n_0 V_c \delta_e F(\mu, \lambda)$, где $F(\mu, \lambda)$ — функция, зависящая от безразмерных параметров $\mu = \delta_e / L_1$ и $\lambda = R_e / R_g$. При $\mu \ll 1$ функция $F(\mu, \lambda) \sim 1$ и $I_1 \sim \epsilon n_0 V_c \delta_e L$, т. е. ионный ток определяется кол-вом ионов, поставляемых потоком газа в электр. пограничный слой (рис. 7, а). При $\mu \gg 1$ функция $F(\mu, \lambda) \approx \mu$ и $I_1 \approx \epsilon n_0 V_c L (1 + T_e/T_c) L / L_1$, т. е. такой же, как и в покоящейся плазме (рис. 7, б). Электронный ток из плазмы на электрод выражается через концентрацию плазмы на границе с лентгоровским слоем, электронную температуру T_e и задерживающий потенциальный барьер U_0 так же, как и в покоящейся плазме.

Лит.: Гривенковский В. Л. Электрический ток в газе, М., 1974; Термодинамика преобразования и кинетики газовой плазмы, под ред. В. Н. Мовсеяна, Г. В. Пануса, М., 1973; Любимов Г. А., Раховский В. И., Катодное пятно вакуумной дуги, «УФН», 1978, т. 125, с. 665; Бажитов Ф. П., Юрьев В. Г. Транзитные явления в низкотемпературной плазме, «ИЗФ», 1979, т. 49, кн. 3, с. 90; Дюжев А. А. и др. Аномальные процессы в сильноточном дуговом разряде, «Химия плазмы», 1983, в. 10, с. 169; Стаханов И. П., Жериков В. В., Физика термостационарного преобразователя, М., 1985; Раваев Ю. П., Физика газового разряда, М., 1987; Рождавский В. А., Пендан Л. Д., Стойковичевский перенос в частично ионизованной плазме, М., 1988; Ф. Г. Вахим, Ф. Г. Юрьев.

ПРОБОЙ ГАЗА — нестационарный процесс итгивания номинальной газа под действием внеш. пост. или перемен. электр. поля при достижении им нек-рой критич. (пороговой) величины. В этом случае «зарубочный» свободный электрон под действием поля набирает энергию, достаточную для ионизации атома, и, вовлекая далее в процесс ионизации газа все новые и новые поколения электронов, порождает *лаvinу электронную*. Наряду с процессами рождения электронов существуют и процессы их исчезновения: прилипание к атомам и молекулам в ад.-отражат. газах, потеря на электродах и диффузия.

П. г. происходит, если скорость рождения электронов превосходит скорость их исчезновения. В случае равенства указанных скоростей существует стационарный разряд.

Газообразные ситуации, к-рые могут разыгрываться при П. г., определяются не только родом и плотностью газа, но и геометрией электродов и разрядной камеры, частотой перемен. эл.-магн. поля. Простейший вариант относится к пробое между плоскими электродами в пост. электр. поле (см. *Паулен закон*). Изучение именно этого вида П. г. возводило Дж. С. Таунсенду (J. S. Townsend) открыть в 1900 электронную лавину и предложить данную теорию П. г.

При рассмотрении П. г. в перемен. эл.-магн. поле с частотой ω вводят новый параметр, равный отношению

амплитуды колебаний электронов (при $v_{en} \ll \omega$) либо амплитуды дрейфовых движений (при $v_{en} \gg \omega$) к характерному размеру разрядной камеры L (v_{en} — частота упругих столкновений электрона с атомами). Напр., для типичных условий СВЧ-пробоя этот параметр имеет величину $\approx 10^{-3}$ ($\lambda = 10$ см, $L = 1$ см).

На рис. 1 приведены эксперим. и теоретич. значения порога СВЧ-пробоя для смеси гелия и паров Hg.

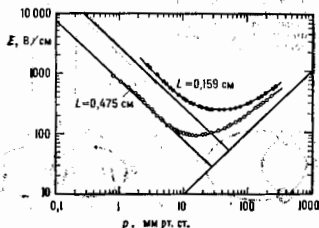


Рис. 1. Зависимость порога СВЧ-пробоя для смеси гелия и паров ртути от давления. Кривые — теория, кружки и точки — эксперимент, $\lambda = 10$ см.

В области низких давлений ($v_{en} \ll \omega$) преобладают потери на ионизацию, и тогда пороговое поле $E_{пр} \propto \omega/pL$; в области высоких давлений ($v_{en} \gg \omega$) напряжение пробоя $E_{пр} \propto p$. Положением минимума соответствует $v_{en} \approx \omega$. Мин. пороги пробоя в СВЧ-диапазоне имеют место при $f \approx 10$ тор, в оптич. спектре — при десятках и сотнях атмосфер (см. *Оптическое разрядное*).

При ВЧ-пробое ($\lambda = 10 \pm 100$ м) возможна ситуация, когда амплитуда колебаний электрона и характерный размер разрядной камеры сравняются. В этом случае появляется ситачок потенциалы зажигания. Физический ВЧ-разряд, что связывается с возрастанием диффузионных потерь электронов на стенках камеры.

Влияние геометрии электродов на параметры П. г. может быть показано на примере зажигания коронного разряда между коаксиальными цилиндрами. В этом случае порог пробоя зависит от радиуса внутри, цилиндра, а также от знака потенциала внутри цилиндра по отношению к внешнему внеш. цилиндру (рис. 2).

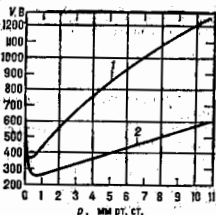


Рис. 2. Зависимость потенциала зажигания для воста между проволокой и коаксиальным цилиндром (радиусы 0,083 и 2,3 см соответственно): 1 — для отрицательно заряженной проволоки; 2 — для отрицательно заряженной проволоки.

Лавинная теория П. г. применима в огранич. области параметра pd (d — расстояние между электродами, p — давление). Отступления от теории возникают как при $pd \rightarrow 0$ (см. *Вакуумный пробой*), так и при возрастании pd . Напр., при атм. давлении время П. г. (время формирования самостоят. разряда) оказывается на два порядка меньше (10^{-7} с при $d = 1$ см), чем следует из лавинной теории, где оно определяется в осн. необходимостью положит. ионов. Л. В. Лёб (L. V. Loeb)

и Дж. М. Мик (J. M. Meek), а также неадекватно от них Х. Ретер (H. Raether) предложил для объяснения высокой скорости формирования самостоят. разряда стримерную теорию; в к-рой учитывается движение газа вокруг первичной лавины в результате переноса ионизации на её головку, а также поперечной характер движения пространственного положит. заряда вдоль востов первичной лавины от анода к катоду (см. *Стримеры*).

При больших d возможен переход в слабоионизов. канала стримера в хорошо проводящий лидер р, обеспечивающий вынос потенциала электрода в глубь межэлектродного промежутка. На рис. 3 дана схема развития положит. лидера при пробое промежутка стержень — плоскость. Скорость удлинения канала лидера увеличивается с ростом крутизны импульса напряжения, достигая 10^7 см/с при крутизне 10^{12} В/с.

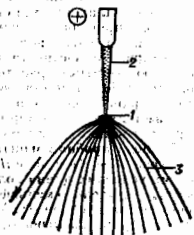


Рис. 3. Схема развития положительного лидера: 1 — головка лидера; 2 — плоскость анода; 3 — стримерная зона лидера.

Вмное потенциала высоковольтного электрода образующимся плазменным стержнем при возбуждении волны пробоя (см. *Ионизационные волны*) исследовался в длинных экранной трубках при крутизне импульса напряжения до $5 \cdot 10^{12}$ В/с.

Характерные особенности данного вида пробоя видны на рис. 4, где представлены зависимости от давления p скорости волны пробоя v вдоль трубки, амплитуды тока I в цепи заземленного электрода и коэф. зажигания α ; характеризующего скорость уменьшения потенциала фронта по мере продвижения волны вдоль трубки. Трубка помещена в коаксиальный металлическ. экран диаметром 5,4 см.

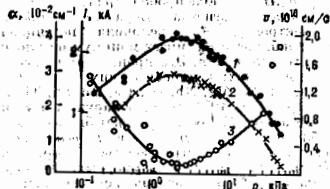


Рис. 4. Характеристики волны пробоя воста в длинной экранной трубке: 1 — скорость волны пробоя v ; 2 — амплитуда тока I ; 3 — коэффициент зажигания α . Внутренний диаметр трубки 0,4 см, длина $\approx 48,5$ см. Импульс напряжения отрицательной полярности с амплитудой 250 кВ, длительностью 9 нс, с фронтом нарастания и спада $\approx 2,5$ нс подавался на один из электродов.

На фронте волны пробоя могут быть достигнуты высокие значения напряженности электрич. поля. Об этом свидетельствует, напр., наблюдаемое рентг. излучение, возбуждаемое волной фронта пучками субэлектронных электронов. Отсюда возникает нек-рое сходство между пробоем в длинных трубках и П. г. атмосферных пучком.

Лит.: Лёб Л. В., Основные процессы электрич. разрядов в газе, пер. с англ., М., 1960; Лёб Л. В. и др.

Сини В. П., Фуршот О. Б. Теория исток. М., 1975; Райзер Ю. П. Физика газового разряда. М., 1967.

ПРОВОД ДИЭЛЕКТРИКОВ — см. в ст. *Диэлектрики*.
ПРОВОД МАГНИТНЫЙ в металлах — квантовое тушевание электронов проводимости в магн. поле H через классически запрещенные области импульсного пространства в местах облистения электронов орбит. При этом переход электронов происходит между траекториями, соответствующим энергии, равной или близкой к энергии Ферми \mathcal{E}_F и одинаковым значениям проекции p_H квазиимпульса p на H , в принадлежащими разным зонам. Предсказан М. Х. Кохом (M. H. Cohen) и Л. М. Фалковым (L. M. Falikov, 1961), экспериментально обнаружен М. Г. Присти (M. G. Priestley, 1963) в Mg. П. м. наблюдается при низких темп-рах и сильных полях ($H \sim 10^4 - 10^5$ Э) в чистых монокристаллах мн. металлов.

П. м. приводит к изменению энергетич. спектра электрона в магн. поле, к перестройке электронных траекторий, в частности к появлению и (или) исчезновению открытых траекторий. Эта перестройка влияет на все свойства металлов, зависящие от магн. поля. Наиб. яркие проявления — осцилляция амплитуды брэгговской дифракции ряда термодинамич. и кинетич. характеристик металла при изменении магн. поля (см. ниже).

Пробоя провод магнитного. Движение электронов с энергией $\mathcal{E} \sim \mathcal{E}_F$ в поле $H \ll 10^6$ квантклассично, т. к. в этих условиях длина волны де Бройля электрона $\lambda \sim \hbar/p_F$ значительно меньше размеров r_H классич. траектории электрона в поле H : $r_H \approx \hbar c / p_F e H$ (p_F — фермиевский квазиимпульс электрона). Межзонные переходы из-за малости отношения $\kappa = \lambda/r_H = \hbar H / c p_F$ (в параметр квантклассичности) могут происходить только в узких запрещенных областях импульсного пространства, где межзонный потенциальный барьер (ширина запрещенной зоны) столь мал, что орбиты разных зон подходят друг к другу на расстоянии $(\sqrt{\kappa} p_F)$, сравнимое с квантовой неопределенностью квазиимпульса $(\sqrt{\hbar H / c})$ в плоскости, перпендикулярной H (рис. 1). Эти области наз. центрами П. м.

Вероятность П. м. определяется ф-лой

$$W = \exp(-H_0/H), \quad (1)$$

где $H_0(\mathcal{E}_F, p_H, H/H)$ — поле пробоя, причём $H_0 \propto \mathcal{E}_F^2 / p_H \mu$, где $\mu = e \hbar c / m c^2$ — магнетон Бора (m — эффективная масса электрона), μ — величина потенциального барьера. Наиб. часто μ имеет минимум на плоскости брэгговского отражения. Это происходит во всех полувалентных металлах, у которых на кжк $H_0 = 10^4 - 10^5$ Э: Al, Be, Ga, Cd, Cr, Mg, Nb, Os, Re, Ru, Sn, Ti, Ta, V, Zn и др. При $H_0 \ll 10^5$ Э П. м. обнаружен и у окислов нек-рых металлов. Малость \mathcal{E}_F может быть также следствием близости к *структурным фазовым переходам* с удвоенным периодом, встречающимся в органических квазидвумерных и квазидвумерных проводниках. Иногда малость \mathcal{E}_F обусловлена пересечением ферми-поверхности с линией конич. точек (точек вырождения зон), на к-рой $\mathcal{E}_F = 0$.

Динамика в спектре электронов. Для описания динамики электронов в условиях П. м. необходимо рассмотреть всю сеть участков их квазидвумерных движения, связанных между собой центрами пробоя. Существуют 3 типа таких конфигураций П. м.: замкнутые конфигурации, типичные для *продольной ориентации H* (рис. 2, верхний *слева*); односторонние периоды конфигурации (рис. 2, верхний *справа* и нижний), возникающие, когда H перпендикулярно одному из векторов обратной решетки b (как правило, числа квазидвумерных участков, пересекающих границы элементарной ячейки в противоположных направлениях, равны); двумерные периоды конфигурации (рис. 3), образующиеся в нек-рых металлах (Al, Be, Mg, Zn,

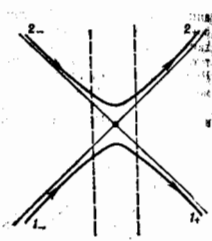


Рис. 1. Траектории (1 и 2) разных энергетических зон — ветви одной гребенки; пунктирные линии схематически отмечают область пробоя; 1, 2 — в 1, 2, 2, 2 — условия квазидвумерности траекторий, входящих в область магнитного пробоя и выходящих из нее; стрелки указывают направление классического движения электронов.

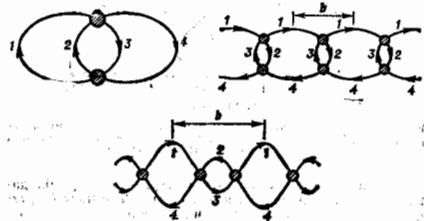


Рис. 2. Конфигурации магнитного пробоя: 1-4 — классические участки; заштрихованные кружки — области магнитного пробоя; стрелки указывают направления движения; верхний *слева* — замкнутая конфигурация, при $W = 0$ распадается на орбиты (1, 4) и (2, 3), при $W = 1$ — на орбиты (1, 2) и (3, 4); верхний *справа* — односторонняя конфигурация с периодом b , при $W = 0$ распадается на замкнутые орбиты (1, 2) и (3, 4), при $W = 1$ — на открытые орбиты (1, 2), (3, 4) и (2, 4); нижний — односторонняя конфигурация, при $W = 0$ распадается на 2 открытые орбиты (1, 1, ...), (4, 4, ...) и замкнутую (2, 3), при $W = 1$ превращается в замкнутую орбиту (1, 2, 3, 4).

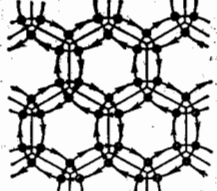


Рис. 3. Двумерная периодическая конфигурация траекторий с осью симметрии b -го порядка (Be, Mg, Zn); при $W = 0$ распадается на замкнутые орбиты — круглоугольные и остроугольные; при $W = 1$ превращается в замкнутую орбиту, составленную из всех участков одной гребни.

Sn) при ориентации H вдоль оси симметрии высокого порядка.

Область П. м. на плоскости p_H — контур может считаться линейной размера точкой (узлом, центром). Электрон, двигаясь по классич. траектории данной зоны (напр., 1 на рис. 1), достигает центра П. м. и здесь испытывает квантовое двунаправленное рассеяние, т. к. есть отличная от 0 вероятность W перехода электрона на классич. траекторию 2 др. зон (в этом и состоит П. м.); одноврем. существует вероятность $(1-W)$ того, что электрон останется на траектории 1-й зоны. Двухнаправленное рассеяние описывается унитарной S -матрицей:

$$S = \begin{pmatrix} \sqrt{1-W} \exp i\Lambda & -\sqrt{W} \\ \sqrt{W} & \sqrt{1-W} \exp (-i\Lambda) \end{pmatrix}.$$

Здесь элементы s_{12}, s_{21} — амплитуды вероятности переходов электронов в одной зоне в другую ($2 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2$), их квадрат s_{11}, s_{22} равен вероятности П. м.

$W(H)$. Элементы $\varphi_{11}, \varphi_{22}$ — амплитуды вероятности переходов без изменения номера зоны; при этом величина $\Lambda(H)$ определяет скачок фазы волновой ф-ции электрона в точке П. м.

При $H \gg H_0$ П. м. происходит с вероятностью, близкой к 1. В этом случае электрон, как и в слабых полях ($H \ll H_0, W = 0$), движется квазиклассически. Однако его траектория другая — она составлена из кусков прежних траекторий.

Динамика электрона при П. м. имеет не квазиклассический, а существенно квантовый характер. Она определяется интерференцией квазиклассич. электронных волн, возникающих при многократном рассеянии электрона на центрах П. м. В этом причина изменения электронного спектра по сравнению с отсутствием П. м.

Замкнутым конфигурациям соответствует электронный спектр типа Ландау — дискретный набор уровней (см. Ландау уровни). В случае одномерных периодич. конфигураций, представляющих собой как бы «слои» в импульсном пространстве, уровни расширяются в магн. зоне. Ширины зон и расстояния между ними при $W(1-W)$ порядка $\hbar\omega_c$, где ω_c — циклотронная частота. Электрон, находящийся на открытой одномерной периодич. траектории, совершает движение поперёк H со ср. скоростью порядка фермиевской скорости v_F .

Стадионарные состояния электронов классифицируются теми же квантовыми числами, что и в отсутствие П. м., однако структура электронного спектра качественно отличается от классической: на разных участках уровни расположены не эквидистантно, а хаотически.

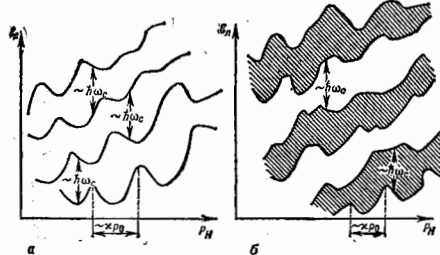


Рис. 4. Уровни в случае замкнутых (а) и периодических (б) конфигураций; зоны вероят. затухания.

Зависимость $\epsilon_n(H)$ также имеет характер неупорядоченных быстрых осцилляций с интервалом изменения $p_n \sim \chi p_F$ и амплитудой $\sim \hbar\omega_0$ (рис. 4). Столь же необычно поведение физ. величин, напр. проясняя на вращении H со ср. скорости электрона $v_n = \partial \epsilon_n / \partial p_n$ при изменении p_n на величину порядка χp_F изменяется на величину $\sim v_F$ и может изменить знак. Электронный спектр при П. м. имеет промежуточный вид между плавным и локально-эквидистантным квазиклассич. спектром и спектром случайных систем (его наз. квазислучайным).

Когерентный и стохастический пробы магнитный. П. м. полностью перестраивает кинетич. свойства металлов в магн. поле $H > H_0$, если время электронной релаксации импульса при $H = 0$ $\tau \gg \omega_c^{-1}$. Обычно при гелиевых темп-рах $T \leq 4,2$ К в отсутствие П. м. τ совпадает с временем релаксации импульса τ_{pr} при рассеянии электронов на примесях (см. Рассеяние носителей заряда в твердом теле). При каждом столкновении с примесью электрон меняет свой импульс на величину порядка самого импульса: $\Delta p \sim p$. Наряду с рассеянием на примесях электрон может рассеивать-

ся на дислокациях (или др. протяженных дефектах решетки), а также на фоновых. Это рассеяние наз. маломугловым τ_{mu}^{-1} . Хотя частота маломуглового рассеяния τ_{mu}^{-1} может быть больше частоты примесного рассеяния, в отсутствие П. м. маломугловое рассеяние неэффективно и слабо влияет на кинетич. характеристики металла, к-рые определяются временем τ_{pr} .

П. м. меняет ситуацию: из-за специфики спектра роль масштаба играет не p_F , а χp_F , и малые переданные импульсы при маломугловом рассеянии оказываются эффективными. Различают 3 случая:

$$\tau_{pr}^{-1} \ll \tau_{mu}^{-1} \ll \omega_c; \quad (a)$$

$$\tau_{pr}^{-1} \ll \tau_{mu}^{-1} \ll \omega_c; \quad (b)$$

$$\tau_{pr}^{-1} \ll \omega_c \ll \tau_{mu}^{-1}. \quad (в)$$

В случаях (а) и (б) столкновит. уширение уровней много меньше расстояния между ними ($\hbar\omega_c$) в время жизни стадионарных состояний (τ_{pr} или τ_{mu}) много больше ω_c^{-1} . В этом случае говорят о когерентном П. м. (см. ниже). В

Система уравнений (в) определяет стохастич. П. м. В этом случае маломугловое рассеяние разрушает электронный спектр, но движение электронов по квазиклассич. участкам конфигурации воумощается слабо. В результате электроны движутся как классич. частицы, совершающие при прохождении центров П. м. случайные перескоки между классич. участками траекторий с вероятностями W и $1-W$. Движение электронов в случае стохастич. П. м. описывается классич. ур-нием Больцмана с электронно-примесным интегралом столкновений, дополненным граничными условиями, описывающими разделение потока электронов на центрах П. м. Выражения для кинетич. коэф. при стохастич. П. м. не содержат характеристик маломуглового рассеяния, роль к-рого сводится лишь к разрушению когерентной квантовой интерференции. Для стохастич. П. м. типичны диссипативные эффекты, характеристики к-рых не зависят от τ_{pr} и τ_{mu} . Они не исчезают при темп-ре $T \rightarrow 0$ К. Время релаксации оказывается порядка ω_c^{-1} , если $W(1-W)$ близко к 1.

Свойства металла при когерентном магнитном пробы (КМП). Зависимость характеристик металла от H прямо разделяет на плавную (в отсутствие П. м. она определяется классич. движением электронов в магн. поле) и осциллирующую, обусловленную квантованием движения электронов в плоскости, перпендикулярной H (см. Гальваноманнитные явления, Квантовые осцилляции в магн. поле, Шубникова — де Хааса эффект).

При КМП не только квантовые осцилляции кинетич. и термодинамич. величин в магн. поле, но и плавная часть кинетич. коэф. определяется квантовой интерференцией путей П. м. — траекторий, к-рые могут описать электрон на конфигурации П. м., произвольно (но непрерывно) перемещаясь по её квазиклассич. участкам. Эта интерференция аналогична интерференции световых лучей: каждому пути сопоставляется его квантовая амплитуда вероятности $A = \text{Вехр}\{\zeta/\hbar\}$, где ζ — суммарное приращение квазиклассич. действия, «набирающееся» при движении электрона, B — проваление элементов s -матриц — амплитуд вероятности перехода между соседними участками пути; в макроскопич. характеристики металла входят суммы амплитуд A всевозможных путей, замкнутых и незамкнутых, имеющих общее начало и конец. При этом осциллирующая часть кинетич. коэф. определяется интерференцией путей с разными квазиклассич. фазами ζ/\hbar , а плавная — интерференцией изофазных путей (о одинаковом ζ/\hbar). Семейства изофазных путей существуют независимо от

топологии, геометрии и симметрии конфигураций П. м.; они образованы путями, проходящими по одним и тем же участкам, но в разном порядке. Два простейших изофазных семейства изображены на рис. 2 (верхний слева: $1-4-2-3-1$ и $1-3-2-4-1$). Число таких путей с увеличением их длины нарастает экспоненциально. Интерференцию изофазных путей можно трактовать как эфф. усреднение по быстрым «дрожаниям» квазислучайного спектра.

Квантово-интерференц. структура кинетич. коэф. при КМП приводит к аномально резкому изменению кинетич. коэф. при отклонении H от осей (плоскостей) симметрии металла на угол $\theta \leq \sqrt{\chi} \sim 1^\circ$, а иногда на $\theta \sim \chi \sim (10^{-2})^\circ$ (КМП-анизотропия; рис. 5). Анизотропия обусловлена тем, что даже слабое отличие геометрически эквивалентных (при $\theta = 0^\circ$) участков, созданное малым поворотом H , приводит к заметной разности квазиклассич. фаз, соответствующих этим участкам, и следовательно — к резкой перестройке всей картины интерференции путей. КМП-анизотропия возникает и при слабом нарушении периодичности конфигурации

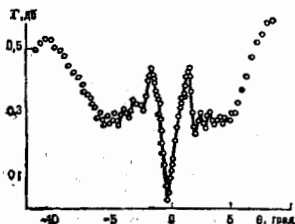


Рис. 5. Зависимость амплитуды осцилляций коэффициента поглощения звука (Γ) в Sn от направления магнитного поля.

П. м. в области малых углов θ между H и плоскостью, перпендикулярной b (рис. 2). При этом металл ведет себя по отношению к поперечному движению электронов как одномерная несовзаимная система, характеризующаяся абс. локализацией электронов с радиусом локализации $\sim (1 + \sqrt{\chi/b})r_H$ или $\sim (1 + \chi/b)r_H$ (см. Андерсоновская локализация). Столь резкая перестройка поперечного (относительно H) движения электронов (от инфинитности при $\theta = 0$ к фазитному при $\theta \neq 0$) ярко проявляется в магнитном сопротивлении металла.

Др. особенность КМП — радикальное изменение структуры резонансного поглощения упрягих в эл.-магн. волн: линии резонансного поглощения упрягих в эл.-магн. волн: старые резонансные пики исчезают, а вместо них появляются более слабые резонансные линии, положение к-рых зависит от вероятности П. м.

Квазислучайный характер спектра при П. м. существенно усложняет картину термодинамич. осцилляций (типа де Хааза — ван Альфена эффекта). Они определяются (как и в отсутствие П. м.) осциллирующей частью плотности электронных состояний вблизи энергии Ферми \mathcal{E}_F . Частоты термодинамич. осцилляций по обратному магн. полю $v(1/H)$ можно представить ф-лой

$$v(1/H) = \frac{c}{eH} \sum_i \pm k_i D_i. \quad (2)$$

Здесь $D_i(\mathcal{E}_F, p_i^1)$ — площади фигур, образованных петлями к.-л. замкнутого пути П. м., p_i^1 соответствует экстремуму выражения (2) на поверхности Ферми, k_i — кратность прохождение петлей; знаки + и — соответствуют электронному и дырочному направлению их обхода. Частоты квантовых осцилляций,

соответствующие неразрешённым (квазиклассическим) орбитам, — характерный признак П. м. Именно такая «странная» частота, к-рая соответствовала площади орбиты — окружности (рис. 3), не помещающейся в элементарной ячейке, впервые обнаружена в осцилляциях магн. восприимчивости Mg.

Осцилляции кинетич. коэф. при П. м. (интерференц. природы) обусловлены не только осцилляцией плотности состояний. Наблюдаются также осцилляции на «квантовых интерферометрах», образованных 2 квазиклассич. участками, напр. 1, 2 на рис. 2 (левый верхний); соответствующая «разностная» частота равна cD_{12}/eH , где D_{12} — площадь лунки, ограниченной участками 1, 2. Очевидно, что при П. м. осцилляции кинетич. величин имеют более широкий спектр частот по сравнению с термодинамическими. В случае конфигураций, близких к двумерным (рис. 3), имеют место необычные осцилляции («звенные»): их частота не зависит от геометрии поверхности Ферми, а равна произведению отношения c/eH на площадь сечения зоны Бриллюэна плоскостью, перпендикулярной H .

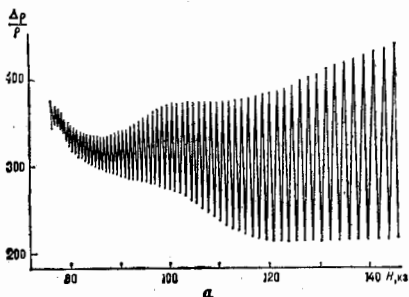
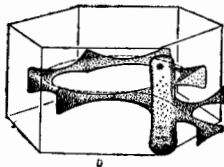


Рис. 6. а — Гигантские осцилляции сопротивления Ве; б — часть поверхности Ферми Ве; магнитный пробой происходит через четверную, отмеченную звёздочкой.



Яркое проявление интерференц. природы П. м. — т. н. гигантские осцилляции кинетич. коэф. Они возникают в случае конфигураций, к-рые состоят из квазиклассич. орбит размерами $\sim r_F$, связанных между собой аномально малыми орбитами. Последние являются квантовыми «затворами», прозрачность к-рых благодаря интерференции квазиклассич. волн, отражённых от центров П. м. на малой орбите, периодична с частотой, равной cD_M/eH , где D_M — площадь малой орбиты. Осцилляции прозрачности, управляя движением электронов, приводят к гигантским осцилляциям, наиб. изученным для галваномагн. характеристик металлов (рис. 6, 7), термодич. и резонансного поглощения звука (рис. 5). Гигантские осцилляции кинетич. коэф. оказываются особо чувствительными к явлению анизотропии П. м.

Интерференц. картина КМП может деформироваться весьма слабыми внеш. полями, способными за время релаксации изменить импульс электрона на малую величину $\sim \hbar r_F$. Это создаёт широкий набор нелинейных эффектов, возникающих при КМП в слабых внеш. полях, на неск. порядков меньших, чем в отсутствие П. м.

В частности возможно заметное отклонение проводимости металлов от закона Ома, а в ряде случаев даже образование падающего участка на вольт-амперной характеристике при напряженности электрич. поля $E \propto \omega \propto T^{-1} \times \rho_0$.

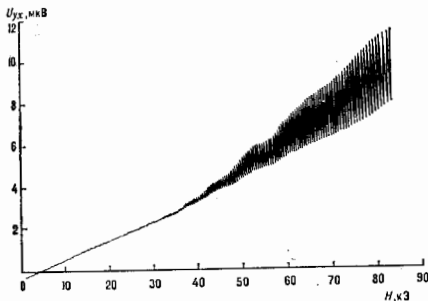


Рис. 7. Гигантские осцилляции поля Холла в Вв.

Дум: Cohen M. H., Falicov L. M., Magnetic breakdown in crystals, «Phys. Rev. Lett.», 1961, ч. 7, р. 231; P. I. G. L. G. G., An experimental study of the Fermi surface of magnetium, «Proc. Roy. Soc.», 1963, v. A278, p. 258; Slutskii A. A., Gurelik L. Yu., Quantum localization in one-dimensional quasi-random systems and magnetic breakdown, «Solid State Commun.», 1983, v. 46, p. 601; S. Andeaga N. B., Stark R. W., Macroscopic quantum coherence and localization for normal-state electrons in Mg, «Phys. Rev. Lett.», 1984, v. 53, p. 1681; Карганов М. М., Слудкин А. А., Магнитный пробой (введение и основные представления), в сб.: Электронная проводимость, М., 1985; Алексеевский И. Н. Е., Экспериментальные исследования когерентного магнитного пробоя, там же.

ПРОБОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — обобщенное название различных по физ. природе процессов, связанных с изменением проводящих свойств среды под действием электр. поля. В результате П. э. резко возрастает ток в среде изнач. неэлектропроводной (или очень слабо проводящей), в нек-рых случаях может измениться агрегатное состояние вещества.

Различают неск. видов П. э. в зависимости от среды, в к-рой он происходит: пробой вакуума, газа, диэлектрика. Пробой электровакuumного промежутка (вакуумной пробой) связан с появлением токового канала. К-ры на нач. этапе может пинцироваться ускоренными в электр. поле заряж. частицами, всегда в небольшом кол-ве неизменяются в промежутке. В результате бомбардировки электродов и вторичной электронной эмиссии ток увеличивается; вследствие теплов. разогрева электродов и их эрозии закипает вакуумная дуга, к-рая горит в материале паров своих электродов. В сильных полях ($\sim 10^7$ В/см) пинцирующий механизм пробоя, как правило, связан с появлением большого автономного тока, а в предельном случае — газовой электронной эмиссии.

П. э. газового промежутка следует рассматривать как нач. стадию электрического разряда в газе. В зависимости от типа разряда могут быть существ. отличия в формировании токового канала и механизме токообразования. Наиб. исследован пробой в тлеющем разряде. Существенно различаются механизмы формирования пробоя в дуговом разряде низкого и высокого давлений, к-рые определяются не только формой электродов и частотой электр. поля, но также и характером нач. эмиссии (термоэмиссия или холодные электроны с формирования пленки).

Своим специфич. особенностями (образование стримеров, молний, коронирование) имеет пробой при искровом разряде (см. также Пробой газа).

П. э. жидких и твердых диэлектриков происходит при достижении определ. напряженности приложенного электр. поля $E_{пр}$, называемой электр. прочностью. В случае пробоя диэлектрик кристалла образует высокопроводящий токовый канал (шнур). Широкое течение тока обычно возникает, когда дифференц. электр. сопротивление становится отрицательным (см. Отрицательное дифференциальное сопротивление, Диэлектрики).

Дит, см. при ст. Вакуумный пробой, Пробой газа, Диэлектрики.

ПРОВОДИМОСТЬ ЗОНА — разрешенная энергетич. зона в электронном спектре твердого тела, не заполненная (в диэлектрике) или частично заполненная (в металлах) электронами при темп-ре $T = 0$ К. В полупроводниках электроны появляются в П. э. при $T > 0$ К (тепловое возбуждение) или под действием света (оптич. возбуждение), сильных полей и т. п. Так как П. э. заполнена электронами лишь частично, последние могут под действием внеш. поля переходить на более высокие уровни энергии в пределах этой зоны. Электроны в валентной зоне, определяющей кинетич. свойства твердых тел — электропроводность и теплопроводность, гальванич. и термоэлектр. явления и т. п. (см. Зонная теория).

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ — способность плазмы пропускать электр. ток под действием электр. поля и сторонних сил (видуч. электр. поля, градиента давления и др.); физ. величина σ , количественно характеризующая это явление. Электр. ток в плазме представляет собой упорядоченное движение электронной и ионной компонент и определяется величиной зарядов, плотностью частиц, их массой и скоростью движения, а также частотами их столкновений:

$$j = \sum_{\alpha} e_{\alpha} n_{\alpha} v_{\alpha} - en_e v_e \quad (1)$$

Здесь j — плотность тока, e_{α} , n_{α} , v_{α} — заряд, плотность и ср. скорость ионов сорта α ; n_e , v_e — плотность и ср. скорость электронов.

В классич. конденсиров. средах (металлах, электролитах) плотность тока j с большой степенью точности линейно зависит от напряженности электр. поля и наводитой эдс (Ома закон):

$$j/\sigma = E + c^{-2}[vH] = E^*, \quad (2)$$

где v — скорость среды, σ — уд. проводимость среды, зависящая от темп-ры.

Простота закона (2) объясняется малой длиной свободного пробега носителей тока. Благодаря этому их движение близко к хаотическому тепловому движению частиц, на к-рое накладывается слабый дрейф вдоль силовых линий электр. поля $E^* \neq 0$.

В плазме пробег частиц может быть самым разнообразным. При давлении порядка атмосферного в низкотемпературной плазме длина свободного пробега невелика ($\sim 10^{-4}$ см), хотя она и больше пробега в конденсиров. средах. В высокотемпературной плазме длины свободных пробегов частиц очень велики. Так, напр., в токах длина свободного пробега $\sim 10^7$ см при $n_e \sim 10^{14}$ см $^{-3}$ и $T_e \sim 10$ кэВ. В этих условиях траектории заряд. частиц определяются преим. не столкновениями, а полями, существующими в плазме, и имеют очень сложный вид, а связь j с E^* теряет локальный характер (см. Перенос процесс). Такое отличие длины свободного пробега, а следовательно и свойств проводимости высокотемпературной плазмы от низкотемпературной, объясняется тем, что сечение «дуононского» столкновения заряд. частиц быстро падает (а длина свободного пробега растет) с ростом относит. энергии ϵ сталкивающихся частиц:

$$\frac{\sigma_{ст}}{\sigma_{ст}^{кул}} = a_0 \epsilon^{-2} \quad (3)$$

Если измерять σ в эВ, то $\sigma_0 \sim 10^{-13}$ см². Следовательно, при $\sigma \lesssim 1$ эВ значение $\sigma_{\text{кул}}^{\text{кул}}$ существенно больше газокинетического ($\sigma_{\text{ст}}^{\text{кул}} \sim 10^{-16}$), но уже при $\sigma \gtrsim 30$ эВ оно равно $\sigma_{\text{ст}}^{\text{кул}}$.

Др. важное отличие плазменных «проводников» от конденсированных заключается в том, что большинство плазменных образований существуют при условии, что через них протекает ток. Таковы классич. электрические разряды в газе, плазма в плазменных ускорителях, токамаках и др. При изменении тока плазменная структура (конфигурация) плазмы или скачкообразно изменяется, в ней могут в широком диапазоне частот развиваться колебания (от акустических до ленгмюровских), на электродах возникать «привяски» и т. п. Около электродов, помещённых в плазму, обычно возникают приэлектродные слои, падение потенциала на к-рых может существенно превосходить падение потенциала в осн. части плазменного объёма (напр., в тлеющем разряде). По этой причине для большинства плазменных систем особое значение имеют не дифференциальные, типа (1), а интегральные характеристики П. п. Для стационарных систем это, в первую очередь, вольт-амперные характеристики:

$$U_p = U_p(I_p), \quad (4)$$

к-рые связывают приложенное напряжение U_p с протекающим через плазменную конфигурацию током I_p . В нестационарных условиях их эквивалентами являются «осциллограммы» тока и напряжения:

$$I_p = I_p(t), \quad U_p = U_p(t). \quad (5)$$

Исключая из этих выражений t , получим для существенно нестационарных разрядов неоднозначные зависимости $U_p(I_p)$.

Если длина свободного пробега частиц достаточно мала, то динамику их поведения в плазме можно описать в гидродинамич. приближении (см. *Двузвучностная гидродинамика плазмы*).

В этом случае для частиц каждого сорта записывается ур-ние движения, учитывающее и давление, и трение компонент друг о друга. Система этих ур-ний предельно упрощена, но тем не менее даёт правильное качественное, а во мн. случаях и количественное описание процессов.

Если время свободного пробега электронов $\tau_{e\alpha} \rightarrow 0$, то усреднённая скорость электронной компоненты оказывается соизмеримой со скоростями тяжёлых компонент, и поэтому, учитывая малую массу электронов, во мн. случаях течение электронной компоненты можно считать барицентричным, а саму её — находящейся в квазиэлектр. состоянии. В результате ур-ние движения для электронов принимает вид обобщённого закона Ома:

$$j/\alpha = E + c^{-1}[\mathbf{v}, \mathbf{H}] + \nabla p_e/en. \quad (6)$$

Переход от (6) к (2) сводится к замене $\mathbf{v}_e \rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{v}_i$ и пренебрежению $\nabla p_e/en \sim kT_e/L$, где L — характерный масштаб неоднородности плазменного образования. Такой переход означает игнорирование Холла эффекта и термоэлектрич. явлений, и это допустимо для конденсиров. сред, где эти эффекты выражены сравнительно слабо. Однако в плазме они могут стать определяющими. Так, напр., в термодерных системах $T_e \sim 10$ кэВ, следовательно, термич. разность потенциалов может достигать десятков кВ. В то же время омический член $[j/\alpha]$ может быть очень малым. Так, напр., в токамаке при ср. плотности тока в шпуре $j \sim 50$ А/см² и $T_e \sim 10$ кэВ П. п. $\alpha \sim 10^7$ (Ом·с)⁻¹. Отсюда $j/\alpha \sim 5 \cdot 10^{-6}$ В/см. В этих условиях большую роль в плазме начинает играть эффект Холла, т. е. в (6) входит не \mathbf{v} , как в (2), а $\mathbf{v}_e = \mathbf{v} - j/en$. Тогда получим

$$j/\alpha = E^* - (en)^{-1}[\mathbf{H}], \quad (7)$$

где

$$E^* = E + c^{-1}[\mathbf{v}, \mathbf{H}] + \nabla p_e/en. \quad (8)$$

Второй член в правой части (7) обычно наз. холловским. В этом случае различают П. п. по полю и поперёк магн. поля (см. *Ома обобщённый закон*). Классич. проводимость σ_i поперёк магн. поля с ростом H убывает $\sim H^{-2}$, а «холловская» проводимость, обуславливая дрейфу электронов в скрещённых $E-H$ -полях, убывает медленнее: $\sigma_{\text{холл}} \sim H^{-1}$. Проводимость вдоль магн. поля от H не зависит. При расчёте тока в плазме по ф-лам (7) и (8) надо знать скорость ионных компонент \mathbf{v}_i . В этом случае токи в плазме определяются не просто проводимостью и в разности потенциалов, приложенной к плазменному промежутку, а являются результатом коллективного взаимодействия всей самоорганизующейся плазменной конфигурации. Если конфигурация осесимметрична, а магн. поле имеет только одну азимутальную компоненту H_z , то такая конфигурация имеет вид неограниченного цилиндра. Это означает, что если имеется гофриров. проводник, то при $H \gg en$ линии элктрич. тока перестают заходить в выступы (рис. 1).

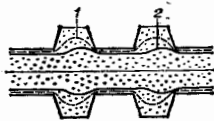


Рис. 1. Линия тока в гофрированном проводнике. 1 — токовая поверхность, внутри которой $I \approx 0,9 I_{\text{макс}}$ при $\sigma H/en = 5$; 2 — то же при $\sigma H/en = 25$.

Величина П. п. α , введённая феноменологически в гидродинамич. рассмотрении, может быть вычислена более строго [1], с использованием *кинетических уравнений* для плазмы, тогда для проводимости ионно-электронной плазмы получим ряд ф-л:

$$\alpha_i \approx 1,96n_i; \quad (9a)$$

$$\alpha_i [\text{абс. ед.}] = \frac{e^2 n_i \tau_{ei}}{m} \approx \frac{0,9 \cdot 10^{18}}{(\Lambda/10)Z} T_e^{3/2} [эВ]; \quad (9б)$$

$$\tau_{e\alpha} = \frac{3\sqrt{m_e} T_e^{1/2}}{4\sqrt{2\pi} \Lambda e Z n}. \quad (9в)$$

Здесь Z — заряд иона, Λ — кулоновский логарифм. В случае полностью ионизованной плазмы проводимость зависит только от темп-ры, возрастая пропорционально $T_e^{3/2}$, и не зависит от концентрации плазмы. Это объясняется тем, что время свободного пробега

$$\tau_{e\alpha} \left(\frac{\text{кул}}{\sigma} n_i v_e \right)^{-1} \propto T_e^{3/2} / n_e,$$

поскольку $\sigma_{\text{кул}}^{\text{кул}} \propto T_e^{-1}$, а $n_i \approx n_e$.

Иначе ведёт себя коэф. электропроводности в случае слабоиониз. плазмы, у к-рой частота столкновений электронов с нейтралами больше, чем с ионами. Его можно определить, зная n_e и τ_{ei} , по ф-ле

$$\sigma^{-1} = (m_e/n_e e^2) \sum_{e\alpha}^{-1}.$$

Если плазма достаточно плотная и близка к равновесной, то оценку концентрации электронов можно получить с помощью *Саха формулы*.

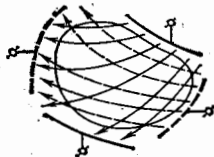
Однако это лишь оценочные расчёты, они могут заметно расходиться с экспериментами из-за загромождения плазмы. Наличие примесей может существенно увеличивать концентрацию электронов. Учитывая, что при малых энергиях частиц σ кулоновское сечение (3) существенно больше ($\sim 10^8 - 10^4$ раз) газокинетического, газ со степенью ионизации $\sim 10^{-3} - 10^{-2}$ мо-

жет уже рассматриваться как сильноионизованный, а его проводимость определяется по ф-ле (9а).

При достаточно редких столкновениях анализа П. п. требует учёта инерции электронов и кинетич. эффектов, таких, как убагание электронов Будкера — Дрейзера (см. *Убагающие электроны*), *приспосабливая проводимость*, *аномальное сопротивление*, а также проводимость за счёт неокислится, переноса (см. *Переноса процессов*).

Благодаря различию скоростей ионной и электронной компонент, приводящему к эффекту Холла, траектории ионов и электронов в плазменных объёмах могут иметь совершенно разный вид (рис. 2). Так, напр., в осесимметричных плазменных ускорителях с замкнутым дрейфом ионы идут вдоль канала в направлении приложенной разности потенциалов, тогда как электроны прет, движутся (дрейфуют) по замкнутым траекториям вдоль азимута, в направлении, перпендикулярном E и H .

Рис. 2. Схематическое изображение траекторий ионов и электронов в плазменном объёме при сильном эффекте Холла; сплошные линии — ионы, штриховые — электроны.



Существование различия ионных и электронных траекторий приводит к тому, что сопряжение плазменных систем с электродами представляет собой весьма непростую проблему и часто требует сложных многоэлектродных систем, примером к-рых могут служить секциониров. электроды МГД-генераторов. Чтобы уменьшить возникающие здесь трудности, часто стремятся траектории той или иной группы частиц (обычно электронов) сделать замкнутыми.

Лит.: 1) Брагинский С. И., Явления переноса в плазме, в сб.: Вопросы теории плазмы, в. 1, М., 1963, с. 183; 2) Райзер Э. П., Основы современной физики газоразрядных процессов, М., 1980. А. И. Морозов. **ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ** — см. *Электропроводность*.

ПРОГРАММА (от греч. πρόγραμμα — объявление, расписание) — заданный набор действий и (или) правил, подлежащих выполнению (проверке) нек-рых исполнителей, обычно автоматич. устройством, чаще всего ЭВМ; предписания, алгоритм. П. выглядит как конечная совокупность команд и действий (инструкций), каждая из к-рых предписывает исполнителю выполнить нек-рую элементарную операцию над данными, хранящимися в памяти исполнителя (см. *Памяти устройства*). Последовательность исполнения П. определяется тем, что любая текущая команда, кроме завершающей, указывает однозначно на команду П., к-рая должна выполняться после текущей. Команды ветвления (усл. переходы) осуществляют выбор одного из нескольких (указанных в команде) продолжений на основании проверки условий, определяющих свойства данных, упомянутых в команде. Кроме того, возможно многократное выполнение отд. команд. Поэтому последовательность выполненных команд и длина этой последовательности при исполнении П. могут варьироваться, однозначно определяясь входными данными. Для П., состоящей из набора действий, её алгоритм заранее определён, в отличие от П., состоящей из набора правил, когда её алгоритм определяется самим исполнителем в процессе выполнения П. Т. о., П. является конечным объектом, к-рый побуждает исполнителя закономерно реагировать на потенциально бесконечное разнообразие входных данных.

Лит.: Математический энциклопедический словарь, М., 1988, с. 494; Язык компьютера, пер. с англ. М., 1989.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ — 1) процесс составления программы, плана действий. 2) Раздел информатики, изучающий методы и приёмы составления программ. С долей условности П. как дисциплина разделяется на теоретическое и практическое, изучающее абстракцию программ (как объектов с определ. логич. и информац. структурой) и способы их построения; системное, имеющее дело с разработкой *программного обеспечения* ЭВМ, т. е. программных комплексов массового и длительного использования; прикладное, обслуживающее конкретные применения ЭВМ во всем их разнообразии.

Составление программы является творческой задачей, т. к. поиски способа достижения даже чётко сформулированной цели в общем случае требуют выработки или привнесения дополнит. знания. В нек-рых частных случаях возможно нахождение более систематической и формальной процедуры П. Так, если задание на П. уже сформулировано в виде алгоритма (точное описание последовательности действий, направленных на решение поставленной задачи), то П. сводится к переводу (трансляции) с языка записи алгоритма (см. *Язык программирования*) на язык, непосредственно воспринимаемый исполнителем (напр., ЭВМ). В нек-рых матем. моделях задача перевода решается исчерпывающе. П. включает поиски систематич. процедур перевода записей алгоритма в программы или создание программ по условиям задачи и дополнит. информации.

Методика П. уделяет особое внимание исходным спецификациям (полной и точной формулировке задачи, к-рую должна решать ЭВМ), поскольку умелое использование заложенной в спецификации информация позволяет придать П. более достоверный характер. Важным аспектом П. является забота о чёткой структуре программы, обеспечивающей проверку её правильности, а главное — выделение и изоляцию тех фрагментов программы, дальнейшая детализация к-рых требует привлечения дополнит. знаний. Ещё одним средством проверки правильности уже составленной программы является её отладка, т. е. систематич. испытание программы на ЭВМ и сравнение производимого эффекта с ожидаемым. Хотя на практике отладка является преимуществ. способом проверки программ, теоретически она не может быть исчерпывающей, т. к. установление правильности программы путём конечной системы испытаний может быть достигнуто только для узкого класса задач.

Реализуют следующие методы П. Связанные с итерацией П. — полное построение программы по заданной спецификации задачи или по общему алгоритму её решения. Структурное П. является комбинацией модульного, восходящего и нисходящего П. Модульное П. опирается на библиотеку модулей (программ с заданными описаниями входных и выходных данных) и состоит в выборе подходящих модулей и в их быстрой (иногда автоматизированной) сборке в результирующую программу. Нисходящее П. решает поставленную задачу путём её последоват. детализации с помощью отд. модулей, в соответствии с обратном порядке путём укрупнения модулей (от более детализированных к менее). Конкретизирующее П. предполагает существование универсальной программы, решающей любую задачу данного класса, и состоит в адаптации универсальной программы к особенностям решаемой задачи. В результате получается либо более простая программа, либо используются меньшие кол-во ресурсов, чем в общем случае. На практике применяются комбинации всех видов П.

Лит.: Вауэр Ф. Л., Гров Г. Г., Информатика, пер. с нем., 2 изд., ч. 1—2, М., 1980; Льюис Дж. Э. С., Мартин Дж. В. Э., Трифонов Н. П., Программирование, М., 1980; Мейер Б., Вольман К., Методы программирования, пер. с франц., т. 1—2, М., 1982; Математический энциклопедический словарь, М., 1988, с. 493—96, 836.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — организованная совокупность программ постоянного употребления, ориентирующая ЭВМ на тот или иной класс

применений. Различают системные П. о., характеризующие данный тип ЭВМ и лежащие в основе любого её применения, и прикладные П. о., ориентированные на конкретный класс задач.

Ядром системного П. о. является операция иная система — комплекс программ, связывающих устройства ЭВМ в единое целое и обеспечивающих фундам. процессы, лежащие в основе исполнения любой программ: управление памятью, заданиями, связь с внеш. памятью в устройствах ввода-вывода, организация совм. исполнения неск. программ, самоконтроль ЭВМ. Следующий слой системного П. о. образуют системы программирования, к-рые осуществляют трансляцию программ с того или иного языка программирования, а также предоставляют средства разработки программ. К системам программирования относятся системы управления базами данных, разовые образцы средства обработки текстовой информации системы телекоммуникации и машинной графики.

Прикладные П. о. разрабатываются обычно в виде пакета прикладных программ (ППП), т. е. программ, образующих целостное единство. Осн. назначение ППП — дать возможность пользователю ЭВМ сформулировать задачу, найти и использовать её решение в понятных и терминах, близких его осн. деятельности и не требующих детального программирования средствами универсального языка. П. о. характеризуется назначением, языками программирования, с помощью к-рых оно реализовано, объёмом исходного текста программ в командах и требующими для функционирования П. о. ресурсами ЭВМ.

Лит.: Фадеев А., Программное обеспечение, пер. с англ., М., 1971; Коростов Л. Н., Структура ЭВМ и их математическое обеспечение, 2 изд., М., 1978.

ПРОДОЛЬНАЯ ВОЛНА — волна, у к-рой характеризующая её векторная величина (напр., для гармонич. волн векторная амплитуда) коллинеарна направлению распространения (для гармонич. волн — волновому вектору). К П. в. обычно относят звуковые волны в газах, жидкостях и изотропных твёрдых телах, *ленгмювские волны* в плазме и др. волны, где колебания частиц могут происходить строго вдоль волнового вектора. Понятие П. в., как и *поперечной волны*, условно и связано со способом её описания. Напр., плоская эл. магн. волна в изотропном диэлектрике или магнетике, обычно рассматриваемая как поперечная, может описываться продольным *Герца вектором*. Строго говоря, к П. в. относятся лишь симметричные, однородные волны (плоские, цилиндрические, сферические). Но, напр., суперпозиция двух плоских продольных (напр., звуковых) волн; распространяющихся под углом друг к другу, порождает неоднородную плоскую волну, в к-рой частицы движутся по эллипсам, различным в разных точках пространства.

М. А. Миллер, Л. А. Островский.
ПРОДОЛЬНОЙ УПРУГОСТИ МОДУЛЬ — см. Модуль упругости.

ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ — деформация изгиба прямого стержня при действии продольных (направленных по оси) сжимающих сил. При квазистатич. возрастании нагрузки прямолинейная форма стержня остаётся устойчивой до достижения нек-рого критич. значения нагрузки, после чего устойчивой становится искривлённая форма, причём при дальнейшем возрастании нагрузки прогибы быстро увеличиваются.

Для призматич. стержня из линейно-упругого материала, снятого силой P , критич. значение даётся ф-лой Эйлера $P_{кр} = \pi^2 EI / (\mu l)^2$, где E — модуль упругости материала, I — момент инерции поперечного сечения относительно оси, соответствующей изгибу, l — длина стержня, μ — коэф., зависящий от способа закрепления. Для стержня, опирающегося своими концами на опору, $\mu = 1$. При малых P — $P_{кр} > 0$ изогнутая ось близка по форме к $\sin(\pi x/l)$, где x — координата, отсчитываемая от одного из концов стержня. Для стержня, жёстко закреплённого на обоих концах,

$\mu = 1/4$; для стержня, к-рый одним концом закреплён, а другой (загруженный) его конец свободен, $\mu = 2$. Критич. сила для упругого стержня отвечает точке *бифуркации* на диаграмме сжимающая сила — характерный прогиб. П. и. — частный случай более широкого понятия — *потери устойчивости упругих систем*.

В случае неупругого материала критич. сила зависит от соотношения $\sigma(\epsilon)$ между напряжением σ и откл. деформацией ϵ при одностороннем сжатии. Простейшие модели упругопластич. П. и. приводят к ф-лам типа Эйлера с заменой модуля упругости E либо на касательный модуль $E_t = d\sigma/d\epsilon$, либо на приведённый модуль E_r . Для стержня призмат. сечения $E_r = 4EE_t / (\sqrt{E} + \sqrt{E_t})^2$.

В реальных задачах оси стержней имеют нач. искривления, а нагрузки приложены с эксцентриситетом. Деформация изгиба в сочетании со сжатием происходит с самого начала нагружения. Это явление наз. *продольно-поперечным изгибом*. Результаты теории П. и. используют для приближённой оценки деформации и несущей способности стержней с малыми нач. возмущениями.

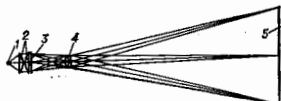
При динамич. нагрузках формы П. и. и продольно-поперечного изгиба могут существенно отличаться от форм потери устойчивости при квазистатич. нагружении. Так, при очень быстром нагружении стержня, опирающегося своими концами, реализуются формы П. и., имеющие две и более полуволны изгиба. При продольной силе, к-рая периодически изменяется во времени, возникает *параметрический резонанс* поперечных колебаний, если частота нагрузки $\theta = 2\omega_j/n$, где ω_j — собств. частота поперечных колебаний стержня, n — натуральное число. В нек-рых случаях параметр. резонанс возбуждается также при $\theta = (\omega_j + \omega_k)/n$, $j \neq k$.

Лит.: Лаврентьев М. А., Ишлинский А. Ю., Динамические формы потери устойчивости упругих систем, ДАН СССР, 1949, т. 84, № 8, с. 778; Вологин В. В., Динамическая устойчивость упругих систем, М., 1956; Вольмир А. С., Устойчивость деформируемых систем, 2 изд., М., 1967; В. В. Волынский, В. В. Волынский.

ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ — оптич. устройство, формирующее изображения оптических объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диакопич., эпикопич. и андиаскопич. П. а.

В андиаскопическом П. а. (рис. 1) изображение на экране создается световыми лучами, прошедшими сквозь прозрачный объект (диапозитив, киноплёнку). Это самая многочисленная и разнообразная группа П.

Рис. 1. Оптическая схема диакопического аппарата: 1 — источник света; 2 — осветительная система (конденсор); 3 — диапозитив; 4 — объектив; 5 — экран.



а., предназначенная для фотопечати, просмотра диапозитивов, чтения микрофильмов и т. д. Разновидностью диакопич. П. а. является кинопроект. аппарат.

Эпикопический П. а. (рис. 2) проецирует на экран изображение непрозрачного объекта с помощью лучей, рассеиваемых этим объектом. К ним относятся эпикопы, приборы для копирования топографич. карт, проецирования рисунков и т. д.

Рис. 2. Оптическая схема эпикопического аппарата: 1 — источник света; 2 — отражатель; 3 — проецируемый объект; 4 — объектив; 5 — зеркало; 6 — экран.



Эти диакопические и П. а. представляют собой комбинация диакопич. и вископич. приборов (см. *Видиаскоп*), допускающую проецирование как прозрачных, так и непрозрачных объектов.

П. а. состоит из механич. и оптич. деталей. Механич. часть П. а. обеспечивает определ. положение объектов относительно оптич. части, смену объектов и требующую длительность их проецирования. Оптич. часть, осуществляющая процесс проецирования, состоит из осветит. системы (включающей источник света и конденсор) и проекц. объектива.

Лит.: В о л о с о в Д. С., Д и н и я н М. В., Теория и расчет светотехнических систем проецирующих приборов, М., 1969; Теория оптических систем. 2-й изд., М., 1981.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР (действующий на векторном пространстве L) — оператор P , определенный на всем L , такой, что $P^2 = P$. Если $L = L_1 \oplus L_2$ — пространство L (пространство $L_1 \oplus L_2$) ф-ций на множестве Ω , интегрируемых с квадратом по мере $d\mu$, тогда L представимо в виде прямой суммы двух ортогональных друг другу подпространств: $L = L_p \oplus L_p^\perp$, причём P действует тождественно на всех векторах $x \in L_p$ и обращает в нуль все векторы $y \in L_p^\perp$. Т. о., оператор P проецирует любой вектор $f \in L$ ($f = x + y$, где $x \in L_p$, $y \in L_p^\perp$) на подпространство L_p : $Pf = x \in L_p$.

Примеры П. о. в физике — операторы, проецирующие на собств. подпространства, отвечающие к.-л. собств. значениям самосопряжённого оператора A спектральные П. о. (см. *Собственные функции*). Метод П. о. широко применяется в матем. аппарате физики.

На множестве всех П. о. можно определить групповые операции сложения и умножения. Обозначим через $P \oplus Q$ П. о. на подпространстве $\Omega \subset L$. Тогда выполнены свойства: $P \oplus P, P \oplus Q, P \oplus P, P \oplus Q, P \oplus P, P \oplus Q$, т. е. различные П. о. коммутируют между собой, и их произведение — опять П. о., если $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$, то $P_{\Omega_1} + P_{\Omega_2} = P_{\Omega_1 \cup \Omega_2}$, т. е. в этом случае сумма П. о. снова даёт П. о.; $P \oplus P_{L/\Omega} = I$, т. е. $P_{L/\Omega}$ будет обратным элементом по сложению. Д. О. Чезков.

ПРОЗРАЧНОСТЬ среды — величина, показывающая, какая доля падающего на поверхность потока излучения (или для видимого света — светового потока) проходит без изменения направления через слой единичной толщины. (Влияние поверхностей раздела, через к-рые проходит излучение, исключается.) Высокий П. обладают среды с направленным пропусканием излучения. В диапазоне видимого света кивов тела на таких сред при подходящих геом. формах предметы видны отчетливо. П. зависит от длины волны излучения; применительно к монохроматич. свету говорят о монохроматич. прозрачности. П. отпадают от пропускания вообще, т. к. среда может быть непрозрачной, но в то же время пропускать рассеянный свет (напр., П. тонких слоев бумаги равна нулю, через них проходит только рассеянный свет). Соответственно П. связана только с коэф. направленного (но не диффузного) пропускания (см. *Пропускание коэффициент*). В слое толщиной 1 см П. оптич. кварца ок. 0,999, оптич. стекла 0,99—0,995.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ — способность атмосферы пропускать направленное излучение. Различают понятия «прозрачность среды» и «пропускание излучения средой». Среда может быть непрозрачной (облака, молочное стекло и др.) и в то же время может пропускать рассеянный свет. Но применительно к атмосфере под пропусканием обычно понимают долю пропускания атмосферой только направленного излучения, поэтому характеристики пропускания и П. з. а. связаны между собой.

Понятие П. з. а. связывалось обычно с возможностью чёткого видения удалённых предметов и обгней, т. е. с условиями пропускания атмосферой видимого излучения. В настоящее время это понятие использо-

ется для характеристики излучения в широком диапазоне длин волн — от рентг. и гамма-излучения вплоть до микроволнового.

Различают спектральную и интегральную П. з. а. Под спектральной П. з. а. понимают способность атмосферы пропускать направленное квазимонохроматич. излучение, т. е. излучение в сравнительно узких участках спектра. Под интегральной П. з. а. понимают способность атмосферы пропускать направленное излучение в широких участках спектра. Для количественного выражения П. з. а. используются разные характеристики. Наиб. употребляемыми из них являются: коэф. пропускания, коэф. прозрачности, фактор мутности и метеорологич. дальность видимости.

В общем случае прозрачность среды характеризуется коэф. пропускания t — отношением потока, прошедшего через среду, к потоку, улавляемому за ней. Величину, обратную t , наз. коэф. ослабления. Отношение потока излучения Φ , прошедшего атмосфере в вертикальном направлении, к внеатмосферному значению потока Φ_0 наз. коэф. П. з. а. $p = \Phi/\Phi_0$. Эта характеристика непосредственно из измерений не определяется, т. к. источник излучения (обычно используют Солнце) бывает в зените лишь в редких случаях. Зависимость потока прошедшей через атмосферу квазимонохроматич. радиации Φ от воздушной (оптич.) массы m в направлении за Солнце (т. е. от отношения оптич. путей наклонного и вертикального лучей) имеет вид

$$\Phi = \Phi_0 p^m, \quad (1)$$

Коэф. пропускания среды t может быть представлен в виде

$$t = \exp\left\{-\int_{l_1}^{l_2} \sigma(l) dl\right\},$$

где интеграл берётся вдоль пути распространения излучения, $l_2 - l_1$ — длина пути. В случае однородной среды $t = \exp(-\sigma(l_2 - l_1))$. Величина σ наз. объёмным показателем ослабления. Он складывается из объёмного показателя рассеяния σ_p и объёмного показателя поглощения σ_n . При прохождении излучения через атмосферу в вертикальном направлении

$$t = p = \exp\left\{-\int_0^\infty \sigma(h) dh\right\} \quad (2)$$

и (1) приобретает вид (закон Бугера — Ламберта)

$$\Phi = \Phi_0 \exp(-\tau m), \quad (3)$$

где τ — оптическая толщина (толщина) атмосферы. Закон Бугера — Ламберта (см. *Бугера — Ламберта — Бера закон*) получен для квазимонохроматич. излучения. При использовании его для расчётов интегральных потоков обнаруживается кажущийся дневной ход коэф. прозрачности. С увеличением воздушной массы m (т. е. с уменьшением высоты Солнца над горизонтом) в проходящем потоке увеличивается доля ДВ-радиации, для к-рой атмосфера более прозрачна, что приводит к кажущемуся увеличению П. з. а. (эфф. кт Φ о б с а). Для исключения влияния этого эффекта коэф. интегральной прозрачности p , полученные при разл. высотах Солнца, приводятся по специальным программам к коэф. интегральной прозрачности p_m при определённой воздушной массе m_0 . Обычно принимают $m_0 = 2$ (т. е. высота Солнца равна 30°). Коэф. p_0 регулярно определяются на метеостанциях в широком диапазоне в актиографии, при изучении атм. процессов, при расчётах радиац. потоков, радиац. баланса земной поверхности и т. д.

Определение коэф. П. з. а. производится по данным абс. и относит. измерений. При абс. измерениях по-

ток лучистой энергии Солнца преобразуется в тепловую энергию, к-рая и регистрируется. Зная *солнечную постоянную*, а следовательно, и внеатмосферное значение потока Φ_0 , по ф-ле (1) определяют коэф. П. з. а. Измерения проводятся на актинометрич. станциях с помощью пиргелометров и актинометров. Данными отключат. измерений прямой солнечной радиации пользуются при определении коэф. П. з. а. методами Бугера — «долгие» и «короткие». При определении П. з. а. «долгие» методом измерения потоков Ф проводят при равной высоте Солнца (т. е. при равных m). Коэф. p определяется по наклону прямой зависимости $\lg F$ от m , в предположении, что в течение измерений П. з. а. оставалась постоянной. При известном для данного фотометра значении внеатмосферной константы Φ_0 (в относит. единицах) определение p может производиться т. н. коротким методом внеатмосферного блеска по ф-ле (1).

Боле чувствительной характеристикой П. з. а. является т. н. фактор мутности атмосферы T — отношение оптич. толщ реальной τ_R и идеальной τ_D (релевской, т. е. когда П. з. а. определяется только релевским рассеянием света) атмосфер. Рассматривая оптич. толщу реальной атмосферы как сумму оптич. толщ идеальной атмосферы τ_D , водяного пара τ_w и аэрозоля τ_a , получают

$$T = 1 + \frac{\tau_w}{\tau_R} + \frac{\tau_a}{\tau_R}.$$

Величину τ_w/τ_R наз. влажной мутностью, величину τ_a/τ_R — остаточной мутностью атмосферы. Т. к. эффект Форбса сказывается одновременно на прозрачности как реальной, так и идеальной атмосфер, фактор мутности почти не зависит от высоты Солнца.

П. з. а. в разл. участках спектра резко изменяется. Так, КВ-излучение Солнца ($\lambda < 290$ нм) практически полностью поглощается верх. слоями атмосферы и до поверхности Земли почти не доходит. На рис. 1 показаны высоты, достигаемые к-рых при вертикальном падении солнечный поток ослабляется в 2 раз. В диапазоне 8—80 нм солнечное излучение поглощается молекулами и атомами азота и кислорода. В области 80—

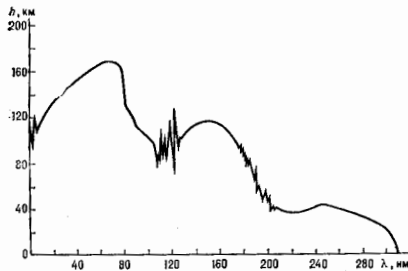


Рис. 1.

200 нм осн. часть излучения поглощается молекулярным кислородом. Немонотонная часть кривой поглощения кислорода на участке 175—202,6 нм формируется системой полос Шумана — Рунге. На участке 200—345 нм УФ-излучение Солнца поглощается озоном в полосе поглощения Хартли (220—320 нм), к к-рой примыкают полосы Хэттванса (300—345 нм).

Коротковолновое УФ-излучение ($\lambda < 290$ нм) может разрушать мн. органич. молекулы (включая ДНК), повреждать земные экосистемы, способствует возникновению рака и др. заболеваний кожи, катаракты, иммунной недостаточности. Наиб. губит. биол. действие

оказывает УФ-излучение в диапазоне 250—260 нм, но как раз на этот участок спектра приходится максимум поглощения озоном в полосе Хартли. Общее содержание озона в атмосфере составляет менее 10^{-9} содержания остальных газов, но этого оказывается вполне достаточно, чтобы защитить Землю от воздействия УФ-излучения. Длинноволновая часть УФ-излучения Солнца ($\lambda > 300$ нм) достигает поверхности Земли и оказывает в осн. благотворное влияние на развитие биол. систем.

В области спектра 350—4200 нм земная атмосфера имеет ряд «очков прозрачности» (рис. 2; приведенная кривая соответствует летним условиям в ср. широтах и общему содержанию водяного пара, равному 2 см осадченной воды) и в целом относительно прозрачна.

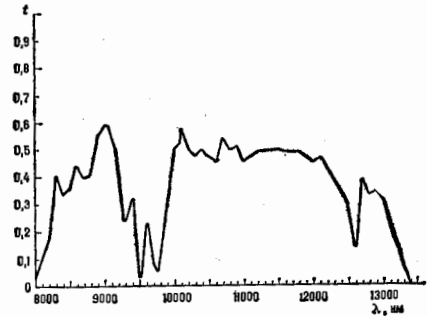
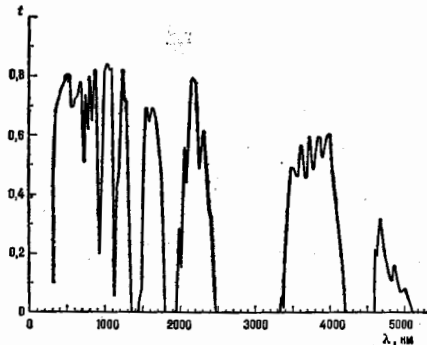


Рис. 2.

Ок. 94% общего потока солнечной энергии на верх. границу атмосферы приходится именно на эту область, причём осн. часть энергии доходит до поверхности Земли. Благодаря этому Земля имеет благоприятный для жизни климат. Ослабление солнечной радиации в КВ-части этой области спектра происходит гл. обр. за счёт рассеяния излучения на молекулах (релевское рассеяние) и на частицах аэрозоля (аэрозольное рассеяние). В ДВ-части этой области солнечное излучение ослабляется в полосах поглощения водяного пара, углекислого газа, озона и ряда др. малых газовых составляющих (NO_x , CH_4 и др.).

Имеется также «окно прозрачности» в области спектра 8000—12000 нм. Коэф. пропускания солнечного излучения в этом «окне» колеблется в ср. в пределах 60—70%. На участках спектра 5200—8000 нм и более 15000 нм солнечное излучение практически полностью поглощается водяным паром.

В связи с использованием лазеров развиваются исследования особенностей распространения лазерного луча в атмосфере. Из-за высокой монохроматичности лазерного излучения даже в «окнах прозрачности» атмосферы лазерный луч может сильно ослабляться. В тонкой структуре спектра поглощения атмосферы в этих «окнах» имеются относительно узкие, но сильные полосы поглощения. Количественные оценки П. з. а. для лазерного излучения требуют знания (с весьма высокой точностью) положения, интенсивности и форм линий тонкой структуры спектров атом. газов. Большая мощность излучения лазеров ($\sim 10^5$ Вт/см²) может вызывать разл. рода нелинейные эффекты (многофотонные эффекты, приводящие к пробую в газах; спектроклионч. эффекты насыщения, вызывающие частичное просветление газов; эффекты самофокусировки оптич. пучков, вызываемых зависимостью коэф. преломления среды от мощности потока излучения, и др.). При малой длительности оптич. импульсов ($\sim 10^{-8}$ с) могут возникать явления, приводящие к отклонению ослабления излучения от закона Бутера.

Характеристикой горизонтальной П. з. а. чаще всего служит метеорологич. дальность видимости L_m — наиб. расстояние, на к-ром в светлое время суток можно различить (обнаружить) невооружённым глазом на фоне неба вблизи горизонта или на фоне воздушной дымки чёрный объект, имеющий размеры более чем $15' \times 15'$. Величина L_m связана с показателем рассеяния σ_p соотношением

$$L_m = 3,9 \frac{1}{\sigma_p} \quad (4)$$

Широко используются инструментальные методы определения метеорологич. дальности видимости, при этом измерит. приборы часто градуируются также в единицах L_m по ф-ле (4). В табл. приводится шкала видимости (в баллах), соответствующая ей пределы L_m в объёмные показатели рассеяния σ_p .

Шкала видимости, соответствующая ей пределы и объёмные показатели рассеяния

Баллы видимости	Погодные условия	L_m , км	σ_p , км ⁻¹
0	Плотный туман	< 0,05	> 78,2
1	Густой туман	0,05—0,2	78,2—19,6
2	Обычный туман	0,2—0,5	19,6—7,82
3	Лёгкий туман	0,5—1,0	7,82—3,91
4	Слабый туман	1—2	3,91—1,96
5	Дымка	2—4	1,96—0,954
6	Лёгкая дымка	4—10	0,954—0,391
7	Ясно	10—20	0,391—0,196
8	Очень ясно	20—50	0,196—0,078
9	Совершенно ясно	> 50	< 0,078
—	Идеальная атмосфера	277	0,0144

Для идеальной атмосферы в табл. приводится средневзвешенное для видимого участка спектра значение объёмного показателя рассеяния $\sigma_p = \sigma_p$. Гидрометеорологич. регулярно проводятся измерения, рассчитываются и выдаются краткосрочные прогнозы дальности видимости для разл. регионов.

Лит.: К о н д р а т ь е в К. Я., Актиниметрия, Л., 1965; З у е в В. Е., Прозрачность атмосферы для видимых и инфракрасных лучей, М., 1966; З у е в В. Е., Кабанов М. В., Перенос оптических сигналов в земной атмосфере (в условиях тумана), М., 1977. В. А. Смирнов.

ПРОИЗВОДИЩЕСТВО ЭНТРОПИИ — прирост энтропии в фаз. системе за единицу времени в результате протекающих в ней неравновесных процессов; одно из осн.

понятий *термодинамики неравновесных процессов*. П. э., отнесенное к единице объёма, наз. л о к а л ь н ы м П. э. Если термодинамич. силы X_i (градиенты темп-ры, концентрации компонентов или их хим. потенциалов, массовой скорости, а в гетерогенных системах — конечные разности термодинамич. параметров) соудают в системе сопряжённые им потоки I_i (теплота, вещества, импульса и др.), то локальное П. э. в такой неравновесной системе

$$\sigma = \sum_{i=1}^n X_i I_i > 0,$$

где n — число независимых действующих термодинамич. сил. Полное σ П. э. равно интегралу от σ по объёму системы. Если термодинамич. силы и потоки постоянны в пространстве, то полное П. э. отличается от локального лишь множителем, равным объёму системы.

Потоки I_i связаны с вызывающими их термодинамич. силами X_k линейными соотношениями

$$I_i = \sum_{k=1}^n L_{ik} X_k,$$

где L_{ik} — онсагеровские кинетические коэффициенты. Следовательно, П. э.

$$\sigma = \sum_{i,k=1}^n X_i L_{ik} X_k,$$

т. е. выражается квадратичной формой от термодинамич. сил.

П. э. отличн. от нуля и положительно для необратимых процессов (критерий необратимости $\sigma \neq 0$). В стационарном состоянии П. э. минимально (*Принцип наименьшего производства энтропии*). Коэффициент, выраженный для входящих в П. э. кинетич. коэф. через потенциалы взаимодействия частиц определяется методами неравновесной статистич. механики или *кинетической теории газов*. В случае теплопроводности П. э. пропорционально квадрату градиента темп-ры и коэф. теплопроводности, в случае вязкого сдвигового течения — квадрату градиента скорости и сдвигового вязкости, в случае диффузии — квадрату градиента концентрации и коэф. диффузии.

Лит. см. при Ст. Термодинамика неравновесных процессов, Д. Н. Зубарев.

ПРОИЗВОДИЩИИ ФУНКЦИОНАЛ — функционал $F[f]$, функциональные производные к-рого по аргументу $f(x)$ дают нулевым набор ф-ций $F_n(x_1, \dots, x_n)$:

$$F_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{\delta^n}{\delta f(x_1) \dots \delta f(x_n)} F[f] \Big|_{f=0}$$

Формально П. ф. представляется рядом

$$F[f] = \sum_{n \geq 0} (n!)^{-1} \int dx_1 \dots dx_n F_n(x_1, \dots, x_n) f(x_1) \dots f(x_n),$$

а ф-ция F_n наз. коэффциентными ф-циями разложения $F[f]$. Функцион. аргумент может быть набором многокомпонентных ф-ций многих переменных: $f(x) = \{f_\mu(x_1, \dots, x_m)\}$, $\mu = 1, \dots, m$. Целесообразность введения П. ф. для набора ф-ций F_n в том, что многие их свойства переносятся на $F[f]$ и компактно записываются на языке П. ф.

Роль П. ф. в *квантовой теории поля* основана на том, что в наиб. употребительном в ней *Поле представления* векторам состояния Φ и операторам \hat{A} по самому их построению отвечают П. ф. (для простоты берётся случай скалярного поля)

$$\Phi = \sum_{n \geq 0} (n!)^{-1} \int d\mathbf{k}_1 \dots d\mathbf{k}_n \Phi_n(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n) \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}_1) \dots \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}_n) \Phi_0 \leftrightarrow$$

$$\leftrightarrow \langle \Phi | a^n \rangle = \sum_{n \geq 0} (n!)^{-1} \int d\mathbf{k}_1 \dots d\mathbf{k}_n \Phi_n(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n) a^n(\mathbf{k}_1) \dots$$

$$\dots a^n(\mathbf{k}_n);$$

$$\hat{A} = \sum_{m, n \geq 0} (m!n!)^{-1} \int d\mathbf{k}_1 \dots d\mathbf{k}_m d\mathbf{p}_1 \dots d\mathbf{p}_n A_{mn}(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_m,$$

$$\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}_1) \dots \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}_m) \hat{a}(\mathbf{p}_1) \dots \hat{a}(\mathbf{p}_n) \leftrightarrow \langle A | a^m, a^n \rangle,$$

где Φ_0 — фоковский вакуум, \hat{a}^\dagger, \hat{a} — операторы рождения и уничтожения частиц с 3-импульсом \mathbf{k} . П. ф. $A[a^\dagger, a]$ наз. нормальным символом оператора \hat{A} , а его разложение получается заменой \hat{a}^\dagger, \hat{a} на комплексно сопряжённые функции a^\dagger, a , а из нек-рого гильбертова пространства. При этом $\langle \Phi | a^n \rangle$ — П. ф. для волновых ф-ций Φ_n n -частичных состояний, а $\langle A | a^m, a^n \rangle$ — П. ф. для матричных элементов A_{mn} оператора \hat{A} в фоковском базисе.

В релятивистской теории в качестве функций, аргументом берётся нормальный символ Φ_0 оператора свободного поля:

$$\langle \Phi_0(x) | \Phi_0(x') \rangle = (2\pi)^{-3/2} \int d\mathbf{k} (2k_0)^{-1/2} \{ \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}) \exp(ikx) + \hat{a}(\mathbf{k}) \exp(-ikx) \},$$

$$k_0 = \sqrt{k^2 + m^2}.$$

Нормальный символ матрицы рассеяния \hat{S}

$$S[\Phi_0] = \sum_{n \geq 0} (n!)^{-1} \int d\mathbf{x}_1 \dots d\mathbf{x}_n S_n(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \Phi_0(\mathbf{x}_1) \dots \Phi_0(\mathbf{x}_n)$$

является П. ф. её коэффициентных ф-ций S_n . Поскольку Φ_0 , как и Φ_0 , удовлетворяют ур-нию свободного поля, \hat{S} и $S[\Phi_0]$ определены лишь на поверхности энергии. Для формулировки причинности вводят расширенный нормальный символ $S[\Phi]$, аргумент к-рого уже не удовлетворяет ур-нию свободного поля. В возмущенной теории этот П. ф. выражается ф-лой Хори

$$S[\Phi] = \exp \left\{ -\frac{i}{2} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} \frac{\delta}{\delta \varphi(\mathbf{x})} D^c(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \frac{\delta}{\delta \varphi(\mathbf{y})} \right\} \times$$

$$\times \exp \left\{ i \int d\mathbf{x} \mathcal{L}[\Phi] \right\},$$

где $D^c(x)$ — причинная ф-ция Грина (пропагатор), $\mathcal{L}[\Phi]$ — нормальный символ лагранжиана взаимодействия. Эта ф-ла компактно записывает результат применения *Вика теоремы* к стандартному выражению для S -матрицы в теории возмущений: $\hat{S} = T \exp \{ i \int d\mathbf{x} \hat{\mathcal{L}} \}$.
 Заменой функций, аргумента у $S[\Phi]$ можно получить П. ф. для Грина функций $G_n(x_1, \dots, x_n)$:

$$Z[J] = \exp \left\{ -\frac{i}{2} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} J(\mathbf{x}) D^c(\mathbf{x}-\mathbf{y}) J(\mathbf{y}) \right\} \times$$

$$\times S \left[i \int d\mathbf{x} D^c(\mathbf{x}-\mathbf{y}) J(\mathbf{y}) \right],$$

где $J(x)$ — внеш. источник поля. Функционал $W[J] = -\ln Z[J]$ является П. ф. для связанных ф-ций Грина. *Лежандра преобразование* $W[J]$ даёт П. ф. для сильно связанных ф-ций Грина, называемый иногда эфф. действием. На языке П. ф. легко выводятся и компактно формулируются *Уорда тождества* и нек-рые др. соотношения между ф-циями Грина.

П. ф. используется и в статистической физике. Напр., введём s -частичные ф-ции распределения N -частичной системы:

$$F_s(t, x_1, \dots, x_n) = V^s \int d\mathbf{x}_{s+1} \dots d\mathbf{x}_N w_N(t, x_1, \dots, x_n),$$

$$s=1, 2, \dots,$$

где V — объём, $x_i = (q_i, p_i)$, а полная ф-ция распределения w_N удовлетворяет *Лиувилля уравнению* $dw_N/dt = \{H, w_N\}$ с Гамильтоном функцией $H = T(p_i) + U(q_i - q_j)$. Тогда всю цепочку *Боголюбова уравнений* для F_s порождает (в термодинамич. пределе $V, N \rightarrow \infty, V/N = v = \text{const}$) ур-ние

$$\frac{\delta F}{\delta t} = dx \{ x \} T, -\frac{\delta F}{\delta(x)} + \int \frac{1}{2} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} \{ f(x) f(y) + v^{-1} f(x) + v^{-1} f(y) \} U, \frac{\delta^2 F}{\delta(x) \delta(y)},$$

для П. ф.

$$F[t; f] = \int d\mathbf{x}_1 \dots d\mathbf{x}_N w_N(t, x_1, \dots, x_N) \prod_{1 \leq i \leq N} (1 + v f(x_i)),$$

а сами F_s выражаются через него ф-лами

$$F_s(t; x_1, \dots, x_s) = \prod_{1 \leq i \leq s} \left(1 - \frac{i}{N} \right)^{-1} \frac{\delta^s F}{\delta(x_1) \dots \delta(x_s)}.$$

Лит.: Березин Ф. А. Метод вторичного квантования, 2 изд., М., 1988; Васильев А. Н. Функциональные методы в квантовой теории поля и статистике, Л., 1976; Славнов А. А., Фаддеев Л. Д., Введение в квантовую теорию возмущений полей, 2 изд., М., 1988; Ицкив со К., Зверев Р. Ж., Б. Квантовая теория поля, пер. с англ., т. 1—2, М., 1984. А. М. Малюжостов, В. П. Павлов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (планетная космогония). Происхождение и эволюция Солнца рассматриваются теориями *звездобразования* и *звездной эволюции*, а при изучении П. С. с осн. вниманием уделяется проблеме образования планет, и прежде всего Земли. Звёзды с планетными системами могут составлять промежуточный класс между одиночными и двойными звёздами. Не исключено, что строение планетных систем и способы их формирования могут быть весьма различными. Строение *Солнечной системы* (СС) обладает рядом закономерностей, указывающих на совм. образование всех планет и Солнца в едином процессе. Такими закономерностями являются: движение всех планет в одном направлении по эллипсич. орбитам, лежащим почти в одной плоскости; вращение Солнца в том же направлении вокруг оси, близкой к перпендикуляру к центр. плоскости планетной системы; осевое вращение в том же направлении большинства планет (за исключением Венеры, к-рая очень медленно вращается в обратном направлении, и Урана, к-рый вращается как бы лёжа на боку); обращение в том же направлении большинства спутников планет; закономерное возрастание расстояний планет от Солнца; деление планет на родств. группы, отличающиеся по массе, хим. составу и кол-ву спутников (группа близких к Солнцу планет земного типа и далёкие от Солнца планеты-гиганты, также подразделяющиеся на 2 группы); наличие пояса малых планет между орбитами Марса и Юпитера.

Краткая история. Начало развитию планетной космогонии положено гипотезой Канта—Лапласа. И. Кант (I. Kant, 1755) выдвинул идею о формировании планет из разреженного пылевого вещества, обращавшегося вокруг Солнца. Согласно П. С. Лапласу (P. S. Laplace, 1796), материалом для образования планет послужила часть газового вещества, отделившаяся от сжимающегося протосолнца. Наряду с гипотезой Канта—Лапласа предлагались гипотезы, основанные на идее *экастастрофич. событий*. В 1920—30-х гг. известностью пользовалась гипотеза Дж. Х. Диниса (J. H. Jeans), считавшего, что планеты образовались из вещества, вырванного из Солнца притяжением протелевезей близости

звезды. Однако уже в кон. 30-х гг. выяснилось, что гипотеза Джинса не способна объяснить размеры планетной системы. Ряд важных исследований по проблеме образования околосолнечной туманности и формирования в ней планет был проведён в 30—40-х гг. Х. Альфвене (H. Alfvén) и Ф. Хойл (F. Hoyle) привлекли внимание к магнитогидродинамич. эффектам, играющим важную роль на ранних стадиях формирования звезды и её окружения. Х. Берлаге (H. Berlage) и К. Вейцэкер (C. Weizsäcker) построили первые газодинамич. модели первичного околосолнечного диска. Начало планомерной разработке теории П. С. с. положено работами О. Ю. Шмидта. В трудах отечеств. школы планетной космогонии вынесены осн. черты эволюции протопланетного диска и процессов, сопровождающих формирование планет. К 80-м гг. получен обширный материал наблюдательных данных по современному звездобразованию. Благодаря полётам космич. аппаратов неизмеримо возрос объём информации о строении, составе и свойствах тел СС. Лаб. изучение внеземного вещества и использование ЭВМ при моделировании астрофиз. событий позволили перейти к построению достаточно детальных количеств моделей П. С. с.

Образование Солнца и допланетного диска. Звёзды солнечного типа образуются в газопылевых комплексах с массой $\geq 10^4 M_{\odot}$ (M_{\odot} — масса Солнца). Пример такого комплекса — известная *туманность Орiona*, в г-рой идёт активное звёздообразование. По-видимому, и Солнце образовалось вместе с группой звёзд в ходе перемежающихся процессов сжатия и фрагментации подобной туманности.

Начавшее сжиматься массивное облако, участвующее в общем вращении Галактики, не может сжаться до высокой плотности из-за большого момента кол-ва движения (момента вращения). Поэтому оно стремится распаться на отд. фрагменты. Часть момента вращения при этом переходит в момент отосит. движения фрагментов. Процесс последоват. фрагментации, сопровождаемый беспорядочными (турбулентными) движениями, ударными волнами, запутыванием магн. полей, притягивным взаимодействием фрагментов, сложен и повият недостаточен. Однако эволюция изолиров. фрагмента с массой $\sim 1 M_{\odot}$, обладающего не слишком большим мом. вращением ($\sim 10^{22}$ г·см²/с), может быть прослежена путём расчётов на ЭВМ. Расчёты показывают, что при большем моменте вращения вместо *протозвёзды* может возникнуть неустойчивое кольцо, разбивающееся на фрагменты. Таким путём, возможно, формируются кратные звёзды. При много меньшем значении момента вращения более вероятно образование одиночной звезды. В 80-х гг. появились первые расчёты по образованию около сжимающейся, медленно вращающейся протозвезды (Солнца) уплотнённого газопылевого диска. Большая часть газа, окружающего протозвезду (вращающаяся оболочка), аккрецирует (см. *Аккреция*) на неё. Согласно оценкам, в экваториальной области сжимающейся протозвезды должна существовать область с интенсивным перераспределением момента вращения. В случае зфф. турбулентности, вызванной продолжающейся аккрецией газа, всё новые порции вещества с избыточным моментом выносятся наружу, образуя вращающийся газопылевой диск. Часть вещества в сжимающейся оболочке аккрецирует непосредственно на диск. За 10^4 — 10^6 лет диск вырастает до размеров порядка радиуса совр. планетной системы (40—50 а. е.) и имеет массу 0,05—0,1 M_{\odot} . Центр. область протозвезды, от к-рой передавался значит. вращат. момент, сжимался, превращаясь в звезду за $\sim 10^6$ лет. Не исключено, что в зависимости от нач. условий в газопылевом комплексе, влияния соседних фрагментов, а также возмущающих близостью *моных звёзд* и *сверхновых звёзд* массы и размеры образующихся дисков могут варьировать в широких пределах. Важную роль в развитии эволюции таких дисков играет активность моло-



Эволюция допланетного диска: а — опускание пыли к центральной плоскости; б — формирование пылевого субдиска; в — распад пылевого субдиска на пылевые ступени; г — формирование из пылевых ступеней компактных тел (по Б. Ю. Лежину, 1984).

дой звезды — её излучение в рентг. и УФ-диапазонах, общая светимость и интенсивность *звёздного ветра*. Согласно этим гидродинамич. моделям околосолнечного газопылевого диска, вращающегося вокруг такого активного Солнца, темп-ра в центр. плоскости диска падает с расстоянием от Солнца r как $r^{-1/2}$ — $r^{-1/3}$, составляя 300—400 К на расстоянии $r = 1$ а. е. и лишь десятки кельвинов на $r = 10$ —30 а. е. Внем. разреженные слои диска могли нагреваться КВ-излучением Солнца до весьма высоких темп-р, что вело к потере газа (его рассеянию в межзвёздное пространство). Этому процессу способствовал также интенсивный солнечный ветер.

Эволюция допланетного диска: динамические аспекты. При моделировании отд. стадий эволюции диска (рис.) и образования планет большое внимание уделяется нач. стадиям — опусканию пылинки к центр. плоскости диска и их слиянию в турбулентном газе. Время опускания пыли и образования пылевого субдиска зависит от интенсивности турбулентных движений в газовой составляющей диска и оценивается в 10^4 — 10^6 лет. При достижении в пылевом слое критич. плотности ($\rho_{кр} \sim 3 M_{\odot}/2л^3$) в результате *гравитационной неустойчивости* пылевой субдиска должен был бы распаться на множество пылевых ступеней. На разных расстояниях от Солнца времена образования пылевых ступеней и их массы могли несколько отличаться, но, по оценкам, в ср. их массы были близки к массам крупнейших совр. *астероидов*. Столкновения ступеней вызывали объединение (и сжатие) большинства из них и образование компактных тел — планет и комет и т. д. Этот процесс, с космогонич. точки зрения, был также весьма быстрым ($\leq 10^6$ лет).

Следующий этап — аккумуляция планет из роя планетезималей и их обломков — занял гораздо больше времени (10^7 — 10^8 лет). Численное моделирование позволяет определять одновременно распределение

масс и скоростей допланетных тел. Сначала тела двигались по круговым орбитам в плоскости породивших их пылевого слоя. Они росли, сливаясь друг с другом и выжаривая окружающее рассеянное вещество (остатки первичной пыли и обломки, образовавшиеся в процессе столкновений планетезималей). Гравитационное взаимодействие тел, усилившееся по мере их роста, постепенно изменяло их орбиты, увеличивая эксцентриситет и с р. наклон к центр. плоскости диска. Наб. массивные тела оказались зародками будущих планет. При объединении в планеты многих тел произошло усреднение их индивидуальных характеристик движения, и поэтому орбиты планет получились почти круговыми и компланарными. Оценочные аналитические и получаемые в численных расчётах отност. расстояния между планетами, их массы и общее число, периоды собств. вращения, наклоны осей, эксцентриситеты и наклоны орбит удовлетворительно согласуются с наблюдениями.

Процесс образования планет-гигантов был более сложным, многие его детали ещё предстоит выяснить. Их образование осложнялось длительным присутствием газовой компоненты и эфф. выбросом вещества во внеш. зоны и даже за пределы СС. Согласно моделям, образование Юпитера и Сатурна протекало в два этапа. На первом этапе, длившемся десятки млн. лет в области Юпитера и около ста млн. лет в области Сатурна, происходила аккумуляция твёрдых тел, подобная той, что была в зоне планет земной группы. Когда крупнейшие тела достигали нек-рой критич. массы ($\geq 5 M_{\oplus}$, M_{\oplus} — масса Земли), начинался 2-й этап эволюции — аккреция газа на эти тела, дивящийся 10^5 — 10^6 лет. Из зоны планет земной группы газ рассеивался за время $\sim 10^7$ лет, в зоне Юпитера и Сатурна он оставался неск. дольше. Образование твёрдых ядер Урана и Нептуна находившихся на больших расстояниях, заняло сотни млн. лет. К этому времени газ из их окрестностей был уже практически потерян. Темп-ры в этой внеш. части СС не превышали 100 К, в результате, помимо силикатной компоненты, в состав этих планет и их спутников вошло много конденсатов воды, метана и аммиака.

Малые тела СС — астероиды и кометы — представляют собой остатки роя промежуточных тел. Крупнейшие из совр. астероидов (поперечником ≥ 100 км) образовались ещё в эпоху формирования планетной системы, а средние и мелкие — в большинстве своём обломки крупных астероидов, раздробившихся при столкновениях. Благодаря столкновениям астероидных тел непрерывно пополняется запас пылевого вещества в межпланетном пространстве. Др. источн. мелких твёрдых частиц — испарение и распад кометных ядер при пролёте их вблизи Солнца. Ядра комет, по-видимому, представляют собой остатки каменисто-ледяных тел зоны планет-гигантов. Массы планет-гигантов ещё до завершения их роста стали столь большими, что своим притяжением начали сильно изменять орбиты пролетающих мимо них малых тел. В результате нек-рые из этих тел приобрели очень вытянутые орбиты, уходящие далеко за пределы планетной системы. На тела, удалявшиеся дальше 20—30 т. а. с. от Солнца, заметное гравитационное воздействие оказали ближайшие звёзды. В большинстве случаев воздействие звёзд приводило к тому, что малые тела переставали заходить в область планетных орбит. Планетная система оказалась окружённой роем каменисто-ледяных тел, простирающимся до расстояний 10^4 — 10^6 а. с. и являющимся источником ныне наблюдаемых комет (облако Оорта).

Происхождение системы регулярных спутников планет, движущихся в направлении вращения планеты по почти круговым орбитам, лежащим в плоскости её экватора, обычно объясняется процессами, аналогичными тем, к-рые привели к образованию планет. Согласно моделям, в ходе формирования планеты в результате неупругих столкновений планетезималей часть из них могла быть захвачена на околопланетную орбиту,

образовав околопланетный доступный диск. Оценки показывают, что характерные времена аккумуляции и разрушения небольших спутников при дроблении много меньше характерного времени образования самой планеты. Вещество в доступных дисках неоднократно обновлялось, прежде чем смогло образоваться относительно устойчивая спутниковая система. Согласно модельным расчётам, массы доступных дисков $\sim 10^4$ — 10^5 от массы планеты, что достаточно для формирования спутниковых систем планет-гигантов. В системе регулярных спутников Юпитера имеется деление на две группы: силикатную и водно-силикатную. Различия в хим. составе спутников показывают, что молодой Юпитер был горячим. Нагрев мог быть обеспечен выделением гравитацион. энергии при аккреции газа. В системе спутников Сатурна, состоящих в осн. из льда, нет деления на две группы, что связывают с более низкой темп-рой в окрестностях Сатурна, при к-рой могла конденсироваться вода. Происхождение иррегулярных спутников Юпитера, Сатурна и Нептуна, т. е. спутников, обладающих обратным движением, а также небольшого внеш. спутника Нептуна, обладающего прямым движением по вытянутой орбите, объясняют захватом. У медленно вращающихся планет (Меркурия и Венеры) спутников нет. Они, по-видимому, испытали приливное торможение со стороны планеты и упали в конце концов на её поверхность. Действие приливного торможения проявилось также в системах Земли — Луна и Плутон — Харон, где спутники, образуя с планетой двойную систему, всегда повернуты к планете одним и тем же полушарием.

Происхождение Луны чаще всего связывают с образованием её на околоземной орбите, однако продолжают обсуждаться и маловероятные гипотезы захвата Земли готовой Луны, отделения Луны от Земли. Разрабатывается и компромиссная гипотеза, связывающая появление массивного околоземного доступного диска с гигантским выбросом вещества, вызванным столкновением протоземли с крупным телом (с размерами порядком Меркурия или даже Марса). Согласно расчётам, из массивного спутникового рои могла образоваться система из неск. крупных спутников, орбиты к-рых с равной скоростью эволюционировали под действием приливного трения, и, в конечном счёте, спутники объединились в одно тело — Луну.

Космохимические аспекты (эволюция состава). В основе физ.-хим. исследований ранних стадий эволюции СС лежат данные по составу межзвёздной и межпланетной пыли, планет и их атмосфер, астероидов и комет. Особое место принадлежит лаб. исследованиям метеоритов — образцов астероидного вещества. Вещество, вошедшее в тела СС, проходило неоднократную физ.-хим. переработку и во многом утратило память о ранних стадиях эволюции. Однако отд. тела СС содержат вещество, хранящее ту или иную информацию в виде реликтовых минеральных фракций, включений и т. п. Образцы такого вещества используются как «космохронометры», «космотермометры», «космосбарометры».

Хим. состав первичного допланетного диска обычно полагают близким к солнечному (среднекосмохимическому). В первичном диске газ (в осн. молекулы водорода и гелия) составлял 98—99% всей массы. Пыль (ферромагнетические силикаты и алюмосиликаты во внутр. части диска, к к-рым добавлялись льды во внеш. части) вначале играла второстепенную роль. В ходе образования и эволюции допланетного диска происходили изменения элементного и изотопного состава газовой и конденсированной компонент, разнообразие процессы обмена между этими двумя осн. резервуарами. Согласно моделям, в процессе образования диска и близлежащего к Солнцу окрестности *межзвёздная пыль* в ходе аккреции испарялась и лишь после частичного охлаждения газа происходила конденсация тугоплавких и умеренно тугоплавких соединений. Во внеш. зоне СС в состав первичных тел могла войти межзвёздная пылевая

компонента. Лаб. анализ образцов наиб. примитивных углистых хондритов указывают на присутствие в них вещества, близкого по особенностям элементного, изотопного и минерального состава к межзвёздной пыли. В целом определения изотопного состава земных и лунных образцов, метеоритов и межзвёздной пыли показывают относительную однородность, а следовательно, хорошую перемешанность осн. массы протопланетного вещества. Это сильный довод в пользу образования дополнительного диска и Солнца в едином процессе. Т. о., установленный для Земли, Луны и древнейших метеоритов возраст в 4,5—4,6 млрд. лет можно считать возрастом СС. В то же время изотопный состав газовой и конденсированной компонент в ходе формирования диска и в последующем при формировании планет несомненно менялся. Интерпретация вариаций содержания отд. изотопов в образцах всеземного вещества частую неоднозначна и зависит от выбора динамич. модели. Важно, однако, что находки донерных продуктов распада короткоживущих изотопов ^{26}Al , ^{107}Pd и др. позволяют получить оценки длительности отдельных ранних стадий. Полученные оценки, основанные на ряде изотопных систем, включающих вымершие короткоживущие изотопы, не противоречат динамич. оценкам длительности стадий формирования планет (10^7 — 10^8 лет).

Ядра крупнейших первичных тел подвергались разогреву до 300—700 К, а иногда и до 1000—1500 К, что достаточно для частичного и полного плавления. Об этом говорят представители особых классов метеоритов, состав и физ. свойства к-рых указывают на то, что их родительские тела прошли стадии нагрева и дифференциации вещества. Причины разогрева до конца неясны. Возможно, он был связан с выделением тепла при распаде короткоживущих радиоакт. изотопов; сущность нагрев мог быть обеспечен взаимными столкновениями.

Ограничения на характер процессов в ранней СС получены при исследовании образцов всеземного вещества, взаимодействовавшего с галактич. и солнечными космическими лучами. Так, исследование зёрен метеоритного вещества, облучённого солнечными космич. лучами, позволило сделать вывод, что к моменту формирования протопланет в зоне земной группы газ в осн. был уже потерян. Это важный аргумент в пользу представлений о вторичности атмосфер Земли, Венеры и Марса.

Начальное состояние и эволюция планет. В результате столкновений растущих планет с телами размером 100—1000 км протопланеты испытывали значит. нагрев, дегазацию, плавление и дифференциацию недр. Изотопный анализ (по изотопам урана и свинца) свидетельствует о раннем образовании земного ядра. Его осн. масса, вероятно, сформировалась более 4 млрд. лет назад, т. е. в первые сотни млн. лет существования Земли. Древний характер поверхностей Меркурия и Луны и ряд косвенных данных о строении Марса и Венеры не противоречат концепции раннего образования ядер планет земной группы. Данные о возможном составе планет говорят о том, что образование ядер планет земной группы произошло вследствие отделения богатого железом расплава от силикатов. Физикохимия процесса отделения железного расплава и динамика опускания его к центру планеты изучены недостаточно. Разогрев планет в ходе их роста сопровождался выделением летучих компонент, содержащихся в веществе рудавших планетезималей. В случае Земли водяные пары конденсировались в воды первичных бассейнов, а газы образовали атмосферу. Согласно изотопному анализу (по изотопам йода и ксенона), осн. масса атмосферы Земли была накоплена к моменту завершения роста планеты. Состав древней атмосферы известен пока плохо.

Процесс хим. расслоения земных недр происходит и в наше время. Лёгкие расплавы в виде магмы поднимаются из мантии в кору. Они частично застревают

и застаиваются внутри земной коры, а частично прорывают кору и в виде лавы изливаются наружу при вулканич. извержениях. Крупномасштабные перемещения вещества в недрах, вызванные тепловой конвекцией и хим. дифференциацией, проявляются в виде подъявмов и опусканий больших участков поверхности, перемещении литосферных плит, на к-рые расчленена земная кора, в виде процессов вулканизма и горообразования, а также землетрясений (см. *Сейсмология*). О совр. строении планетных недр см. в ст. *Планеты и спутники*.

Лит.: Protostars and planets, т. 1—2. Туслов, 1978—85; Сафронов В. С., Витязев А. В., Происхождение Солнечной системы, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Астрономия, т. 24, М., 1983. А. В. Витязев.

ПРОКА УРАВНЕНИЕ — ур-ние свободного векторного поля $F_{\mu\nu}$ с массой m и спином 1:

$$\partial_{\mu} F_{\nu\lambda} + m^2 V_{\mu} = 0,$$

где $\partial_{\mu} = \partial/\partial x_{\mu}$, $\mu = 0, 1, 2, 3$; $F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} V_{\nu} - \partial_{\nu} V_{\mu}$. П. у. эквивалентно системе Клейна — Гордона уравнения ($\square + m^2$) $V_{\mu} = 0$ и условия Лоренца $\partial_{\mu} V_{\mu} = 0$. Благодаря свободному полю Прока описывает четыре, а три (непрерывные) степени свободы и отвечает спину 1. Формально при $m = 0$ П. у. переходит в Максвелла уравнения; получающееся безмассовое векторное поле приобретает калибровочную инвариантность и отвечает лишь двум физ. степеням свободы. Это обстоятельство делает невозможным непосредств. переход от квантовой теории массивного векторного поля к квантовой теории безмассового поля. Проблема перехода решается Штюкельберга формализмом, дающим альтернативное описание массивного векторного поля.

Лит.: Умэдзава К., Квантовая теория поля, пер. с англ., М., 1958; Огижевский В. И., Подубарик И. В., Калибровочно-инвариантная формулировка теории свободного векторного поля, «Изв. АН УССР», т. 41, с. 247; Икисон К., Зюбер Ж.-Б., Квантовая теория поля, пер. с англ., т. 1—2, М., 1984. В. П. Павлов.

ПРОМЕЖУТЧНА ВАЛЕНТНОСТЬ — специфич. состояние ионов в твёрдом теле, при к-ром в ионном остове имеется в среднем не целое (дробное) число электронов. Термин «П. в.» применяется в осн. по отношению к соединениям редкоземельных элементов и актиноидов, реже — переходных металлов. При формировании твёрдых тел из атомов или ионов их валентные электроны обычно уходят на образование хим. связей либо переходят в зону проводимости, а электроны частично заполненной $4f$ -оболочки вследствие малого её размера ($\sim 0,4 \text{ \AA}$) остаются локализованными в ионном остове. Типичное значение валентности редкоземельных элементов 3+. Это означает, что атом покидают 3 валентных электрона. Их $4f$ -оболочка заполнена частично, т. е. в ней меньше 14 электронов. Существуют, однако, аномальные редкоземельные элементы, у к-рых сечение атома имеет нестандартную валентность: $4+$ у Ce и Pr, $2+$ у Sm, Eu, Tm, Yb. Появление валентностей, отличных от 3+, обусловлено особой стабильностью пустых либо целиком заполненных оболочек. Напр., атомы Ce наряду с валентностью 3+, при к-рой $4f$ -оболочка атома содержит 1 электрон ($4f^1$), имеют валентность $4+$, когда $4f$ -оболочка пуста ($4f^0$). Атомы Yb наряду с валентностью 3+ ($4f^{13}$) имеют валентность 2+ ($4f^{14}$). Аналогичная картина наблюдается в случае ровно валовую заполненных $4f$ -оболочек: Eu^{2+} ($4f^7$) вместо Eu^{3+} ($4f^6$). В результате для соответствующих атомов

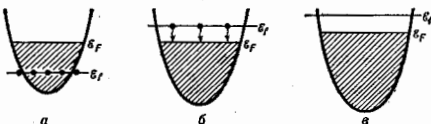


Рис. 1. а — Электронная структура редкоземельного металла; б — переходы с изменяемой валентностью; в — опустошение f -уровня.

(ионов) в кристалле часто оказываются энергетически близкими равные валентные состояния (неустойчивая валентность) и новые редкоземельных элементов имеют в ср. дробное число $4f$ -электронов. Соединения с П. в., как правило, являются *металлами*, хотя среди них встречаются и *полупроводники* с очень малой шириной запрещенной зоны: $\epsilon_g/k \leq 10^3$ К («золотая» фаза SmS , SmB_2 , YbB_{12}).

Системы с неустойчивой валентностью соответствуют случаю, когда f -уровень (ϵ_f) лежит вблизи уровня Ферми ϵ_F у металлов или вблизи зоны проводимости ϵ_c у полупроводников. При изменении внеш. условий (давления, темп-ры, состава соединения) ϵ_f может сдвигаться; напр., под давлением он перемещается

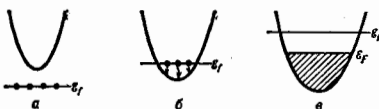


Рис. 2. а — Валентная структура редкоземельного полупроводника; б — переходы с изменением валентности; в — опустошение f -уровня и превращение в металлическую структуру.

вверх; если он при этом пересечёт ϵ_F (ϵ_c), то энергия f -электронов станет больше, чем энергия свободных состояний в зоне проводимости (рис. 1, 2). При этом возможен переход f -электрона из локализованного в делокализов. состояние, т. е. $f-c$ переход с изменением валентности. В случае конденсатов. систем такой переход обычно является *фазовым переходом 1-го рода*. Переход с изменением валентности под давлением наблюдается у SmS , SmSe , SmTe . При переходе сохраняется симметрия решётки (типа NaCl), но происходит скачок параметров решётки; скачком меняются также электрич., оптич. и магн. свойства (проводимость, коэф. отражения, магн. восприимчивость и т. д.). По-видимому, также объясняется γ - α переход в *черни* под давлением (симметрия решётки в обеих фазах одинакова — *гранцентрированная кубическая*). Если f -уровень поднялся над ϵ_F или ϵ_c невысоко, то не все f -электроны «вылущиваются» с f -оболочки. При этом в состояниях, возникающих в результате подобных переходов, наблюдается П. в.

В нек-рых соединениях (SmS_2 , Eu_2S_4) П. в. является термически активированной. В этом случае дробная валентность связана с наличием атомов 2 типов, напр. с валентностью $2+$ и $3+$. При высоких темп-рах между ними происходит быстрый обмен электронами, т. е. переход $\text{Eu}^{2+} \leftrightarrow \text{Eu}^{3+}$. При понижении темп-ры в этих веществах происходит фазовый переход с упорядочением расположения ионов в разных (целочисленных) валентных состояниях (напр., чередование определ. образом ионов Eu^{2+} и Eu^{3+}) и П. в. исчезает. Такие соединения наз. соединениями с неупорядоченной валентностью.

Обычно же под собственно П. в. имеют в виду др. ситуацию, когда все ионы эквивалентны, а дробное значение валентности возникает из-за того, что каждый ион всё время занимает своё состояние, но захватывая электрон на f -уровень, то «выбрасывая» его в зону проводимости (рис. 3). Т. о., в каждом ионе происходит флуктуация валентности, дающие в ср. целое заполнение f -состояний. В этом случае флуктуации имеют квантовую природу и сохраняются вплоть до $T = 0$ К.

С квантовомеханика. точки зрения, в этом случае волновая ф-ция электрона ψ является суперпозицией волновых ф-ций ψ_f и ψ_c :

$$\psi = \alpha\psi_f + \beta\psi_c.$$

Здесь α определяет вероятность найти электрон на f -оболочке и число f -электронов $n_f = |\alpha|^2$. Из-за неоп-

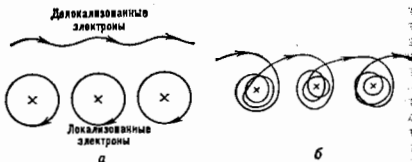


Рис. 3. а — Движение электронов по делокализованным орбитам и коллективизированным; б — движение электронов, участвующих в промежуточной валентности.

редённости соотношения конечное время жизни τ состояния f -электрона означает неопределённость его энергии $\Delta\epsilon_f \tau = \hbar$. Энергетич. уровень ϵ_f приобретает ширину $\Gamma = \Delta\epsilon_f = \hbar/\tau$, превращаясь в т. н. резонанс, лежащий вблизи ϵ_F и заполненный электронами частично (рис. 4). Энергетически в резонанс попадают конфигурации $4f^n$, $4f^{n-1}$. Частичное заполнение резонанса и есть промежуточное значение n_f , т. е. П. в.

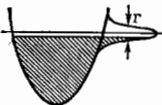


Рис. 4. Валентная структура соединения с промежуточной валентностью.

Нестабильность валентности и возможность перехода f -электрона в зону проводимости и обратно (мезкофигурац. флуктуации) существенно проявляются в большинстве физ. свойств систем с П. в. Т. к. энергия $4f$ -уровня лежит вблизи ϵ_F , то размытие уровня ϵ_f приводит к появлению вблизи ϵ_F узкого пика в плотности состояний $g(\epsilon)$ с шириной, пропорциональной Γ^2 , где V — матричный элемент $f-c$ перехода (рис. 5).

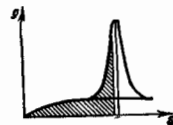


Рис. 5. Плотность электронных состояний в системах с промежуточной валентностью.

Соответственно системы с П. в. имеют характерную темп-ру T^* ($kT^* \sim \Gamma$) и частоту ω мезкофигурац. флуктуаций, определяющую соотношением $\hbar\omega \sim \Gamma$. Типичные значения $T^* \approx 10^2 - 10^3$ К. В системах со слабой П. в., когда заполнение f -оболочки близко к целому, напр. в соединениях Се, где валентность $\leq 3,05$, $T^* \sim 1-10$ К (см. *Кондо-решётки, Тяжёлые фермионы*).

В конденсат. системах число состояний в пике $g(\epsilon)$ велико (~ 1 на ячейку) и уровень Ферми фиксируется в окрестностях этого пика. Повышение плотности состояний на уровне Ферми проявляется в большинстве термодинамич. свойств систем с П. в.: большой коэф. γ в линейной части температурной зависимости *электронной теплоёмкости* ($C_e = \gamma T$, $\gamma \propto (T^*)^{-1}$), большое значение магн. восприимчивости ($\chi_0 \sim \chi$), часто заметное возрастание сжимаемости и т. д. Типичные значения γ в системах с П. в. $\sim 30-300$ мДж/моль \cdot К² (соединения с $\gamma \sim 400$ мДж/моль \cdot К² относят обычно к системам с тяжёлыми фермионами). Заметно проявляется П. в. и в кинетич. свойствах, что можно объяснить резонансным рассеянием электронов проводимости на f -уровне, лежащем вблизи ϵ_F .

Соединения с П. в. часто являются пограничными между немагн. соединениями и магнетиками, содержа-

тими локализмов. магн. моменты. Если соединения редкоземельных элементов имеют стабильную 4f-оболочку с педочисленным заполнением электронами в с локализмов. магн. моментом, то f-уровни лежат глубоко под уровнем Ферми ϵ_F . В системах с нестабильной валентностью f-уровень ϵ_f оказывается ближе к ϵ_F . По мере его приближения к ϵ_F система последовательно переходила бы от магн. состояния при $\epsilon_f \ll \epsilon_F$ (целая валентность) к т. н. режиму Кольдо при $\epsilon_f \sim \epsilon_F$ (валентность близка к целой; см. Кольдо эффект). Далее при $\epsilon_f \sim \epsilon_F$ возникает истинная П. в., а при $\epsilon_f > \epsilon_F$ валентность снова становится целой (на 1 больше исходной).

В большинстве редкоземельных элементов с П. в. одно из двух находящихся в резонансе валентных состояний является немагнитным: $\text{Ce}^{4+}(4f^0)$, $\text{Yb}^{3+}(4f^{14})$, $\text{Eu}^{3+}(4f^6)$; для них переход с изменением валентности — одновременно переход из магн. состояния в немагнитное. Фазы с П. в. в них обычно не имеют дальнего магн. порядка. Исключение — некоторые соединения Eu, в к-рых, по-видимому, П. в. иногда существует с магн. упорядочением, а также соединения Tm, где обе возможные конфигурации (Tm^{2+} и Tm^{3+}) являются магнитными и где в фазе с П. в. есть дальний магн. порядок (напр., TmSe).

Валентность ионов редкоземельных элементов определяют экспериментально разл. способами. Простейший метод основан на том, что ионы с разной валентностью имеют разные ионные радиусы (см. Атомный радиус), и соответствующие кристаллы будут иметь разные значения параметра решетки a . Зная a , напр. для соединения RS при двухвалентном и трехвалентном состояниях иона R, и измеряя параметр a , можно увидеть, ложится ли он на верхнюю или нижнюю части кривой на рис. 6 или лежит между ними; последнее соответствует П. в.

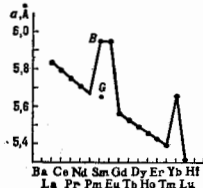


Рис. 6. Изменение параметров решетки в ряду сульфидов редкоземельных элементов: В — параметр решетки SmS -полупроводника («черная фаза»); G — параметр решетки в металлическом состоянии («золотая фаза»).

Др. способ основан на зависимости положения междоузловой линии от валентного состояния иона, особенно в соединениях Eu^{2+} , Eu^{3+} (см. Мессбауэровская спектроскопия). Используются также зависимость от валентности расположения линии рентг. спектров, характеристик фотоэлектронной эмиссии и др.

У соединений актиноидов в силу большего радиуса 5f-оболочки (сравнительно с 4f) 5f-состояния часто оказываются более делокализованными, и понятие валентности (заполнение 5f-оболочки) для них менее определено. Экспериментально определить валентное состояние таких ионов в кристалле затруднительно в силу той же причины, а также потому, что магн. свойства этих ионов в разных валентных состояниях часто близки.

1. Системы с П. в., наряду с прямикающими к ним соединениями с тяжёлыми фермионами и решётками Кольдо, представляют интерес как в связи с уникальными свойствами, так и ввиду их ограниченного положения между состояниями с локализов. и коллективизиров. электронами, между магн. и немагн. состояниями, иногда между металлами и диэлектриками (SmS , SmB_6) (рис. 2). Широкого применения они пока не нашли, хотя используются для записи и хранения информации, в датчиках и др.; важным может оказаться явление П. в. и в катализе.

Лит.: Хомский Д. И. Проблема промежуточной валентности. «УФН», 1979, т. 129, с. 443; с его же. Необычные электронные в кристаллах (промежуточная валентность и тяжёлые фермионы), М., 1987; Lawrence J. M., Riseborough P. S., Park R. D., Valence fluctuation phenomena, «Berl. Beitr. Phys.», 1981, т. 44, № 1.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ — термодинамически устойчивая доменная структура, возникающая при фазовых переходах 1-го рода, индифферентных магн. полем. П. с. появляется в образце конечного размера в веществе, у к-рого под действием магн. поля возможен фазовый переход 1-го рода из состояния с меньшей намагниченностью (фаза I) в состояние с большей намагниченностью (фаза II). В образце, обладающем размагничивающим фактором N , такой переход не может осуществляться скачком, т. к. если бы весь образец при достижении магн. полем критич. величины H_c перешёл в новую фазу, то из-за увеличения размагничивающего поля внутр. магн. поле стало бы меньше критического. Поэтому образец разбивается на чередующиеся области фаз I и II так, что внутр. поле остаётся постоянным в равных H_c . Образуется П. с. Переход образца в фазу II происходит по мере увеличения магн. поля от H_c до $H_c + \Delta H$ (ΔH — разность магн. восприимчивостей обеих фаз).

П. с. было впервые предсказано и обнаружено у сверхпроводников первого рода при переходе в нормальное состояние под действием магн. поля (см. Промежуточное состояние сверхпроводников). Др. пример П. с. — магнитная доменная структура, к-рая появляется в лёгкоосных антиферромагнетиках вблизи спин-флип перехода (см. Антиферромагнетизм).

Лит.: Вильямс А. Р., Физика магнитных доменов, «УФН», 1988, т. 156, с. 47.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ сверхпроводников — возникает в образце из сверхпроводника первого рода под действием внеш. магн. поля или магн. поля тока, протекающего по образцу. П. с. реализуется, когда напряжённость магн. поля H в определённых точках поверхности образца достигает величины критического магнитного поля H_c , однако при полной утрате сверхпроводящих свойств (в тех же внеш. условиях) невозможно выполнить условие $H \geq H_c$ для всего образца. П. с. представляет собой смесь сверхпроводящих и нормальных доменов, характерный размер к-рых много меньше размеров образца. Термин «П. с.» введён Р. Пайерлсом (R. Peierls, 1936), структура П. с. была высказана Л. Д. Ландау в 1937. В неоднородном внеш. поле в образце могут одновременно существовать большие области сверхпроводящей и нормальной фаз. Они обязательно разделены веществом в П. с. Под действием тока, протекающего по образцу, может осуществляться т. н. динамич. П. с., в к-ром границы раздела непрерывно движутся через образец (со скоростями $10^{-3} - 10^{-2}$ см/с), зарождаясь на одной его поверхности и исчезая на другой.

Образец в сверхпроводящем состоянии, помещённый в однородное постоянное внеш. магн. поле H_0 , искажает пространство. однородность H_0 . Незатухающие электрич. токи, текущие в слое толщиной $\delta \sim 0,1$ мкм (δ — глубина проникновения) вблизи поверхности образца, локально экранируют поле H_0 , так что внутри образца $H = 0$ (Мейснера эффект). Вне образца неоднородное магн. поле экранирующих токов складывается с H_0 , создавая картину силовых линий, огибающих образец. В качестве типичного примера рассмотрим образец в форме шара (рис. 1, а). Две точки, в к-рых вектор H_0 перпендикулярен поверхности шара, наа. «полюсами», а линия, вдоль к-рой H_0 насасает поверхности шара, наа. «экватором». На поверхности образца макс. напряжённость поля $H_{\text{макс}}$ достигается на «экваторе», а мин. напряжённость $H_{\text{мин}} = 0$, на «полюсах». В сверхпроводящем состоянии $H_{\text{мин}} = 0$, $H_{\text{макс}} = 3H_0/2$.

Шар переходит в П. с. для значений H_0 , удовлетворяющих условию $2H_0/3 < H_0 < H_c$. При этом на «полюсах» $H_{\text{мин}} = 3H_0 - 2H_0$, на «экваторе» $H_{\text{макс}} = H_0$, и во ва-

висит от величин H_e . Часть магн. потока проникает в образец. В объёме образца возникает чередующиеся домены нормальной (h) и сверхпроводящей (S) фаз. В нормальных доменах поле $H = H_e$, в сверхпроводящих — $H = 0$. Границы между h — S -доменами параллельны вектору H_e и простираются вдоль H_e на всю толщину образца. Сечение h — S -границ плоскостно, перпендикулярно H_e , имеет вид извилистых линий, расположение к-рых определяется неконтролируемыми факторами. Масштаб структуры h — S -доменов (d) в плоскости, перпендикулярно H_e , зависит от величины поля. При $H_e \approx 0,8 H_c$ характерная величина $d \approx \sqrt{\xi D}$, где D — диаметр шара, ξ — длина когерентности (см. Гинзбург — Ландау теория). Эксперименты с оловянными шарами при $D = 4$ см и $\xi = 0,3$ мкм дали значение $d \approx 0,2$ мм, близкое к расчётному. Нормальные и сверхпроводящие области с размером $d \gg \xi$ могут сосуществовать в равновесии только в сверхпроводниках 1-го рода, где глубина проникновения магн. поля $\delta < \xi \sqrt{2}$. Для сверхпроводников второго рода при $H > H_{c1}$ (H_{c1} — величина 1-го критич. поля) возникает смешанное состояние, в к-ром нельзя выделить нормальные и сверхпроводящие области, т. к. характерный масштаб микроскопич. структуры смешанного состояния $d' \approx \xi < \xi \sqrt{2}$. Макроскопич. электродинамика П. с. использует величины напряжённости поля H_1 и магн. индукции B_1 , усреднённые на расстояниях $L \gg d$. H_1 и B_1 удовлетворяют ур-ниям магнетостатики $\text{div} B_1 = 0$, $\text{rot} H_1 = 0$. На поверхности образца выполняются обычные условия непрерывности перпендикулярной компоненты B и тангенциальной компоненты H . В П. с. силовые линии $B_1 \parallel H_1$ — прямые, а величина $H_1 = H_e$ (усреднение по h -доменам) и не зависит от внеш. поля. Для шара в однородном внеш. поле $B_1 \parallel H_e$ (рис. 1, б), а $B_1 =$

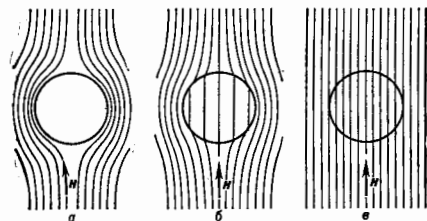


Рис. 1. Распределение магнитного поля около сверхпроводящего шара: а — сверхпроводящее состояние; б — промежуточное состояние; в — нормальное состояние.

$= 3H_e - 2H_c$ достигает величины критич. поля при $H_e = H_c$. При $H_e > H_c$ образец любой формы переходит в нормальное состояние. В отличие от обычного магнетика связь между B_1 и H_1 величина. Роль магн. проницаемости играет величина $\mu = B_1/H_e$. В нормальном состоянии с хорошей точностью $\mu = 1$ поле становится всюду однородным: $B_1 = H_1 = H_e$ (рис. 1, в).

Для провального эллипсоида вращения, помещённого в однородное внеш. поле H_e , ур-ния магнетостатики имеют решения, выражаемые в элементарных функциях. При этом эллипсоид намагничен однородно, т. е. $B_1 = \text{const}$. Если вектор H_e направлен вдоль одной из осей эллипсоида, то $B_1 \parallel H_e$. П. с. возникает в диапазоне $(1 - m)H_c < H_e < H_c$. Положительный коэф. $m \leq 1$ зависит от отношения полусей эллипсоида и наз. *размагничивающим фактором*. Величина индукции в образе $B_1 = H_e - (H_c - H_e)m$. Для сферы фактор $m = 1/3$. Длинный цилиндр можно рассматривать как предельный случай сильно вытянутого эллипсоида. Для вектора H_e , параллельного оси цилиндра, $m = 0$.

Поэтому в длинном цилиндре в продольном поле П. с. не возникает. При $H_e = H_c$ образец переходит из сверхпроводящего в нормальное состояние, а индукция скачком меняется от нуля до $B_1 = H_c$. В поперечном поле размагничивающий фактор длинного цилиндра $m = 1/2$. Если образец имеет форму тонкой пластины, то его можно рассматривать как предельный случай сильно сплюснутого эллипсоида, причём для ориентации вектора H_e перпендикулярно плоской поверхности пластины $m \approx 1$ и диапазон П. с. $0 < H_e < H_c$ начинается с очень малых полей. В этом случае $B_1 = H_e$.

Для экзперим. изучения структуры П. с. применялись разл. типы миниатюрных датчиков магн. поля, напр. висмутовые измерители. Для визуального наблюдения структуры h — S -областей использовалась техника декорирования ферромагн. порошками, основанная на том, что ферромагн. частицы втягиваются в область сильного поля, т. е. в места выхода S -доменов на поверхность образца (рис. 2). Наиб. мощным сор. методом, позволяющим изучать динамику движения h — S -доменов, является магнитооптический. На зеркальной поверхности образца наносится прозрачная плёнка материала с очень высоким коэф. фарадеевского вращения плоскости поляризации (см. *Фарадеев эффект*). Как правило, для этого используются соединения редкоземельных элементов, напр. $\text{EuS} + \text{EuF}_2$. Линейно поляризованный свет, отражённый от образца, наблюдается через скрещенные поляризаторы (см. *Магнитооптика*). Участки выхода на поверхность образца S -доменов кажутся тёмными, а вблизи h -доменов, где плёнка повер-



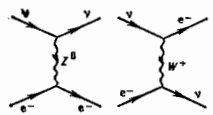
Рис. 2. Фотография промежуточного состояния в сверхпроводящей пластине, полученная методом ферромагнитных порошков. Тёмные полосы — выход на поверхность h -доменов, светлые — S -доменов.

нёт плоскости поляризации, видны светлые участки. Таким способом удаётся наблюдать даже очень сложную картину течения извилистых h — S -доменов в чистых и совершенных образцах при пропускании электрич. тока.

Лям: Л. в. а. у. Д. Д., Л. в. ф. и. Е. М. Электродинамика оптических сред. 2 изд., М., 1982; Л. в. ф. и. З. А., Сверхпроводимость, пер. с англ., 2 изд., М.: 1971; Абрикосов А. А., Основы теории металлов, М., 1987.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЕКТОРНЫЕ БОЗОНЫ — векторные частицы, за счёт обмена к-рями осуществляется слабое взаимодействие. Они наз. «промежуточными» по историч. причинам, поскольку их существование было предсказано теоретически задолго до их прямого обнаружения как реальных частиц (1983), а именно, локальное четырёхфермионное взаимодействие между заряженными токами и нейтральными токами представлялось как результат «промежуточного» обмена виртуальными частицами W^+ и Z^0 [на рис. в качестве примера показано, как неуважный обмен осуществляется в рассеянии нейтрино (ν) на электроне

(σ). Эти бозоны являются промежуточными в том же смысле, что и фотоны (γ) в рассеянии заряд. частиц. Обмен векторными бозонами W^{\pm} (электрич. заряд соответственно $+e$ и $-e$), Z^0 (электрич. заряд 0) и γ осуществляет связь между токами в единой теории электрослабого взаимодействия, основанной на группе симметрии $SU(2) \times U(1)$. В этой теории массы W^- (массы W^+



и W^- равны) и Z^0 -бозонов вычисляются теоретически и выражаются через константы Ферми G_F и Вайнберга угла θ_W :

$$m_W = \frac{1}{\sin 2\theta_W} \left(\frac{\pi \alpha}{\sqrt{2} G_F} \right) = \frac{37,3}{\sin 2\theta_W} [\text{ГэВ}],$$

$$m_{Z^0} = \frac{m_W}{\cos \theta_W},$$

где $\alpha = 1/137$ — постоянная тонкой структуры. Угол Вайнберга и массы m_W, m_{Z^0} измеряются в независимых экспериментах, поэтому справедливость приведенных соотношений с процентной погрешностью служит очень важным аргументом в пользу теории электрослабого взаимодействия.

Масса (m_W) и ширина (Γ_W) заряд. W -бозона равны соответственно 80,6 \pm 0,4 ГэВ и 2,25 \pm 0,14 ГэВ, масса (m_{Z^0}) и ширина (Γ_{Z^0}) нейтрального Z^0 -бозона равны 91,161 \pm 0,031 ГэВ и 2,534 \pm 0,027 ГэВ. Заряд. W -бозон в 70% случаев распадается в адронные состояния, в 30% — в лептонные состояния $e\nu, \mu\nu$ и $\tau\nu$ (относительная вероятность каждой лептонной моды равна 10%). Z^0 -бозон распадается в адронные состояния в 71% случаев, его лептонные моды соответственно: e^+e^- (3,2%), $\mu^+\mu^-$ (3,36%), $\tau^+\tau^-$ (3,33%) и $\nu\bar{\nu}$ (19,2%).

М. В. Терентьев.

ПРОМЕТИЙ (Prometium), Pm, — радиоактивный хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 61, относится к лантаноидам. Выделен Дж. Марински (J. Marinsky), Л. Глендением (L. Glendenin) и Ч. Корваллом (C. Coryell) из продуктов деления U в 1945. Нечетные кол-ва П. обнаружены в земной коре. Известны изотопы ^{145}Pm и ^{147}Pm , наиб. долгоживущим является малодоступный ^{146}Pm (электронный захват и α -распад, $T_{1/2} = 17,7$ год). Наиб. значимые ищут β -радиоактивный ^{147}Pm ($T_{1/2} = 2,623$ года), к-рый в заметных кол-вах образуется в ядерных реакторах. Конфигурация внешних электронных оболочек $4f^5 5s^2 5p^6 6s^2$. Энергия последоват. ионизации атома 5,55; 10,90; 22,3 и 41,1 эВ соответственно. Металлич. радиус атома Pm 0,182 нм, радиус иона Pm^{3+} 0,099 нм. Значение электроотрицательности 1,07.

Металлич. П. имеет гексагональную кристаллич. структуру, параметры решетки $a = 0,365$ нм и $c = 1,165$ нм, плотность 7,26 кг/дм 3 , $t_{пл} = 1080$ — 1170 $^{\circ}\text{C}$ (по реал. данным), $t_{кип}$ ок. 3000 $^{\circ}\text{C}$. Уд. теплоемкость $c_p = 27,59$ Дж/(моль \cdot К), теплота плавления 8,8 кДж/моль. Коэф. линейного расширения $8 \cdot 10^{-6}$ К $^{-1}$.

По хим. свойствам схож с др. лантаноидами, степень окисления +3. Нуклид ^{147}Pm — компонент светосоставов длительного (до неск. лет) действия, его используют в источниках радиоакт. излучения в атомных батарейках.

С. С. Вербицкий.

ПРОНИЦЕМАЕМОСТЬ МАГНИТНАЯ — см. *Магнитная проницаемость*.

ПРОПАГАТОР (функция распространения, причинная функция Грина) в квантовой теории поля (КТП) — функция, характеризующая распространение релятивистского поля (или его кванта) от одного акта взаимодействия до другого. П. является решенной классич. волнового уравн. в δ -образной правой частью, удовлетворяющим специфич. крайним условиям. Простейший П. $D^{\epsilon}(x-y)$ скалярного поля $\varphi(x)$ описывает распространение скалярной частицы между точками пространства-времени x и y и может быть представлен в виде 4-мерного интеграла Фурье

$$D^{\epsilon}(x-y) = (2\pi)^{-4} \int e^{ik(x-y)} \Delta^{\epsilon}(k) d^4k,$$

$$\Delta^{\epsilon}(k) = (m^2 - k^2 - i\epsilon)^{-1}, \quad \epsilon \rightarrow \pm 0.$$

Бесконечно малая явная добавка $i\epsilon$, отвечающая упомянутым выше крайним условиям, даёт правило обхода полюсов $\Delta^{\epsilon}(k)$, так что после выполнения интегрирования П. оказывается представляемым в виде $D^{\epsilon}(x-y) = \Theta(x^0 - y^0) D^+(x-y) - \Theta(y^0 - x^0) D^-(x-y)$. Т. о., при $x^0 > y^0$ он совпадает с отрицательно-частотной частью перестановочной функции Паули — Йордана (см. также *Сингулярные функции*), равной вакуумному среднему $D^{\epsilon}(x-y) = i \langle \varphi(x)\varphi(y) \rangle$, а при $x^0 < y^0$ — положительно-частотной части, т. е. $i \langle \varphi(y)\varphi(x) \rangle$. Поэтому

$$D^{\epsilon}(x-y) = i \langle T\varphi(x)\varphi(y) \rangle,$$

где T — символ хронологического произведения; при $x^0 > y^0$ описывает распространение скалярного кванта из y в x , а при $x^0 < y^0$ — из x в y . Важность П. в КТП связана с тем, что он является осн. понятием ковариантной теории возмущений и фигурирует в правилах Фейнмана. Центр. роль П. в квантовополевой теории возмущений впервые установиле Л. Гивье (D. Rivier) и Э. Штокельбергом (E. Stueckelberg).

Ф-цию распространения, учитывающую радиак. поправки при движении частицы между точками x и y , наз. одетым проагатором или двухточечной ф-цией Грина.

Лит.: Ривьер Д., Штокельберг Э. A convenient expression for the magnetic moment of the neutron. *Phys. Rev.* 1948, v. 74, p. 218; Рейзуан Р. Р. Theory of positrons, там же, 1949, v. 76, p. 749; его же, Space-time approach to quantum electrodynamics, там же, p. 760; Боролюбов Н. Н., Штокельберг Э. В. Квантовые поля, М., 1983. Д. В. Ширков.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КАМЕРА — электронный координатный детектор частиц, представляющий собой множество пропорциональных счетчиков, имеющих общий катод и заключенных в газовой объём. Действие П. к. основано на определении координаты точки траектории частицы по обрабатываемому одному из счетчиков.

Имеется большое кол-во разновидностей П. к. — плоские, цилиндрические и т. п. [1-4]. Принцип действия можно объяснить на примере плоской П. к., в к-рой имеются 2 плоских катода и в центре между ними анод в виде тонких параллельно натянутых сигнальных проволочек (симметричная П. к.). Анодные проволочки диаметром d удалены на расстояние a друг от друга и l от катода (катоды делают из тонкой металл. фольги). На П. к. подается высокое напряжение V_0 , величина к-рого зависит от геометрии камеры, прежде всего от расстояния между проволочками. В симметричной П. к. при $l > a > d$, $V_A = V_0$, $V_K = 0$ (рис. 1) потенциал точки с координатами x, y равен

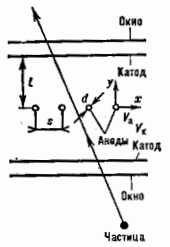
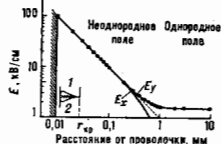


Рис. 1. Схема пропорциональной камеры (сечение).

$$V(x, y) = (e/l) \ln \left(\frac{2nl/s}{2nl/s - \ln[\sin^2(\pi x/s) + \sin^2(\pi y/s)]} \right).$$

Здесь $g = V_0 C = V_0 2\pi \epsilon_0 [n/l s - \ln(d/s)]$ — заряд на единицу длины сигнальной проволоки, ϵ_0 — диэлектрич. проницаемость газа, C — уд. ёмкость сигнальной

Рис. 2. Зависимость напряженности электрического поля E от расстояний r частицы от сигнальных проволок: 1 — область газового усиления; 2 — область высокой плотности пространственного заряда.



проволочки. Типичные параметры П. к.: $l = 8$ мм, $s = 2$ мм, $d = 20$ мкм, $C = 3,47$ пФ/м, $V_0 = 4-5$ кВ. Электроны, образовавшиеся на траектории заряда, частицы вследствие ионизации атомов газа, движутся (дрейфуют) к анодной проволоке. В её непосредств. близости, начиная с критич. радиуса $r_{кр}$, происходит лавинообразное размножение электронов (газовое усиление; рис. 2). Электр. поле вблизи проволоки обладает цилиндр. симметрией (рис. 3), поэтому процесс газового усиления происходит так же, как

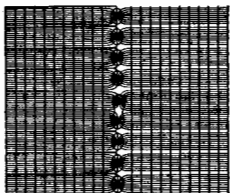


Рис. 3. Эквипотенциальные и силовые линии электрического поля в пропорциональной камере.

и в цилиндрич. пропорциональном счётчике. Коэф. газового усиления (в т. в. приближении Роуза — Корфа)

$$K = \exp\{2kNCV_0 d / (4\pi\epsilon_0)^{1/2} [(V_0/V_{кр})^{1/2} - 1]\}.$$

Здесь N — плотность газа, $V_{кр}$ — пороговое напряжение, соответствующее $y = r_{кр}$. Амплитуда A сигнала, поступающего с каждой сигнальной проволоки, пропорциональна иониз. потерям заряд. частицы, т. е. числу электронов n , вошедших на данную сигнальную проволочку:

$$A = enK/C.$$

Пропорциональность между ионизацией и амплитудой A достигается при $K = 10-10^3$.

К каждой сигнальной проволоке присоединяют предусилитель, после к-рого сигнал поступает в устройство, кодирующее номер проволоки. П. к. размещают так, чтобы частицы летели примерно перпендикулярно плоскости сигнальных проволок, и тогда координата z точки траектории частицы определяется номером работавшей проволоки. Чтобы получить неск. точек на траектории частицы, неск. П. к. соединяют в блоки (рис. 4), причём соседние П. к. обычно

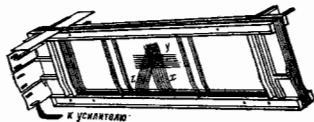


Рис. 4. Схема блока из трёх пропорциональных камер, размещающих координаты x, y, z (развернута на 25° к z).

взаимно развернуты на 90° . Обычно применяют десятки П. к., что позволяет полностью реконструировать траекторию заряд. частиц.

Разрешающая способность. Пространств. разрешение П. к. задается расстоянием между сигнальными проволочками s . Среднеквадратичная ошибка измерения координаты $\Delta z/x \approx s/3$. Амплитудное, т. е. энергетическое, разрешение П. к. определяется соотношением

$$\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 = \left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2,$$

где Δn — флуктуации числа электронов, ΔK — флуктуации газового усиления от каждого электрона. При регистрации мягких γ -квантов ($E_\gamma = 5-6$ кэВ) в П. к. достигается разрешение $\approx 12-15\%$ при $K = 10^2-10^3$ [5, 6]. При $K < 10^2$ разрешение ухудшается из-за уменьшения отношения сигнал/шум; при $K > 10^3$ начинает проявляться накопление положит. заряда вблизи проволоки, что ухудшает амплитудное разрешение (см. ниже).

Временное разрешение П. к. δt определяется временем дрейфа ионов. При $s = 2$ мм временное разрешение $\delta t = 30$ нс.

Измерение 2 координат в одной пропорциональной камере. Существует неск. методов определения координаты z траектории частицы вдоль сигнальных проволок [7]. Часто используют т. н. метод деления токов, основанный на измерении токов I_1 и I_2 на концах сигнальной проволоки. Токи разделяются соответственно сопротивлениям R_1, R_2 участков проволоки по одну и другую стороны от места прохождения частицы: $I_1/I_2 = R_2/R_1 = (L - z)/z$, где L — длина проволоки. Предельная точность метода: $\Delta z/L \sim 1\%$. Координату z определяют также измерением индуктив. заряда на катодах, к-рые изготовлены в виде i полосок или площадок шириной 5-8 мм; на каждой полоске измеряется заряд Q_i :

$$z = \frac{\sum Q_i z_i}{\sum Q_i}.$$

Этот метод обеспечивает пространственное разрешение $\Delta z/z = 20-30$ мм.

Характеристики пропорциональных камер. Газовая смесь для П. к. должна обеспечивать достаточно высокие уд. иониз. потери энергии заряд. частиц (≈ 2 кэВ/см), мин. сечение захвата электронов атомами газа, гасящие свойства при развитии электрон-фотонной лавины вблизи сигнальных проволок. Этим требованиям удовлетворяют смеси инертных газов и углеводородов (или CO_2). В П. к. обычно используют смесь Ar (70-90%) и CH_4 (10-30%).

Большое газовое усиление достигается в П. к. с тонкими сигнальными проволочками. Однако при этом эл.-статич. силы отталкивают проволочки друг от друга и требуется достаточно большое их натяжение: $T > (1-4\pi\epsilon_0)(CV_0 L/s)^2$ (предельное натяжение вольфрамовой проволочки с $d = 10, 20, 30$ мкм равно 0,16, 0,65 и 1,45 Н). Критич. длина проволоки $L_{кр} = (s/CV_0)(4\pi\epsilon_0 T)^{1/2}$. При $s = 2$ мм, $l = 8$ мм, $d = 20$ мкм и $V_0 = 5$ кВ $L_{кр} = 85$ см, поэтому в П. к. больших размеров необходимо укреплять сигнальные проволочки.

П. к. работает с высокой эффективностью в потоках до 10^4-10^5 частиц/мм²с. Препятствием увеличения загрузки является накопление положит. заряда вблизи сигнальных проволок. В процессе газового усиления положит. ионы, подвижность к-рых приблизительно в 10^3 раз меньше подвижности электронов, накапливаются около проволоки, экранируя её, уменьшают газовое усиление и понижают эффективность регистрации частиц.

Долговечность П. к. ограничена старением, к-рое возникает из-за осадения и полимеризации органич.

соединений на поверхности проволочек [8]. Старение заметно после попадания 10^{14} электронов на 1 мм длины проволочки.

Многонитные камеры применяют не только в пропорциональном, но также и в др. режимах работы, напр. в самогасящем стримерном режиме. При этом теряется пропорциональность амплитуды и ионизации, но возрастает амплитуда сигнала (см. *Стримерная камера*).

П. к. используют в физике частиц высоких энергий, где крупные установки, достигающие площади $\sim 40 \text{ м}^2$, содержат десятки П. к. с общим числом проволочек веск. десятков тысяч, а также в ядерной физике, биологии, в медицинской диагностике, дефектоскопии и т. д.

Лит.: 1) Rice-Evans P., Spark, streamer, proportional and drift chambers, L., 1974; 2) Sauli F., Principles of operation of multiwire proportional and drift chambers, Gen., 1977; 3) Заневский Ю. В., Проволочные детекторы элементарных частиц, М., 1978; 4) Заневский Ю. В., Пешехонов В. Д., Пропорциональные и дрейфовые камеры в прикладных исследованиях. Обзор, «Приборы и техн. инструменты», 1978, № 2, с. 7; 5) Баули F., Basic processes in time-projection like detectors, in: Time projection chamber 1-th workshop, Vancouver, 1983, N. Y., 1984; 6) Ионизационные измерения в физике высоких энергий, М., 1988; 7) Ситар В., Новые направления в развитии дрейфовых камер, «ЭЧАЯ», 1987, т. 18, с. 1040; 8) Аленсеев Г. Д., Кружков В. В., Хаваис Д. М., Самогасящие стримеры (СГС) разряда в проволочной камере, «ЭЧАЯ», 1982, т. 13, с. 703.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК — газоразрядный детектор частиц, создающий сигнал, амплитуда к-рого пропорциональна энергии, выделенной в его объеме регистрируемой частицей. При полном торможении частицы в объеме П. с. амплитуда сигнала пропорциональна энергии \mathcal{E} частицы, т. е. П. с. является одновременно и спектрометром. П. с., как и др. газоразрядные детекторы, представляет собой газовый объем (от веск. см³ до веск. л) с 2 электродами. От конструкции *ионизационной камеры* П. с. отличает форма анода в виде тонкой нити или острей для обеспечения вблизи анода значительно большей напряженности электр. поля, чем в остальном пространстве между анодом и катодом. Наиб. распространены цилиндрич. П. с., где катодом является металлч. цилиндр (корпус счетчика), внутри к-рого аксиально протянута тонкая проволока — анод (рис. 1).

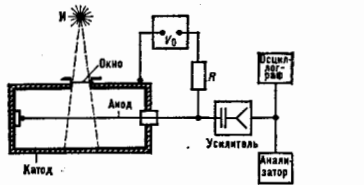


Рис. 1. Схема пропорционального счетчика: И — источник частиц.

Заряд, частица с энергией \mathcal{E} создает в газе $n_0 = \Delta\mathcal{E}/W$ электрон-ионных пар, где $\Delta\mathcal{E}$ — *ионизационные потери* энергии частицы, W — ср. энергия образования электрон-ионной пары. Импульсы тока (напряжения), возникающий на сопротивлении R , пропорционален \mathcal{E} ; импульсы (1—100 мВ) усиливаются и поступают в регистрирующее (анализирующее или запоминающее) электронное устройство.

Газовое усиление. Первичные электроны, образовавшиеся заряд, частицей в результате ионизации газа, под действием электр. поля перемещаются к аноду, по пути многократно сталкиваясь с атомами (рис. 2). Эти соударения частично неупругие, т. к. электроны теряют значит. часть своей энергии и не могут набрать энергию, достаточную для ионизации атомов газа (20—30 эВ). В цилиндрич. П. с. электр. поле

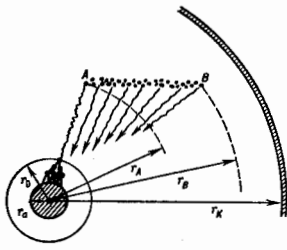


Рис. 2. Механизм работы пропорционального счетчика: $r_K - r_A$ — зона дрейфа первичных электронов; $r_к - r_а$ — зона лавины.

$E \sim r^{-1}$, где r — расстояние частицы до нити (рис. 3). Поэтому между двумя последоват. столкновениями электроны, приближаясь к аноду, получают все возрастающие значения кинетич. энергии, и на нек-ром расстоянии от нити r_0 энергия становится достаточной для ионизации. Образующиеся вторичные электроны вместе с первичными участвуют в последующей лавинной ионизации газа (газовое усиление). Коэф. газового усиления M — отношение кол-ва электронов, пришедших на нить, к числу первичных электронов. Форма электронно-ионной лавины вблизи анода сильно зависит от значения M : при $10 < M < 100$ лавина приобретает форму капли в направлении прихода электронов на анод; при $10^3 < M < 10^4$ лавина становится сердцевидной, вытянутой в направлении прихода электронов; при $M > 10^4$ лавина полностью охватывает анод — тогда и нарушается пропорциональность между n_0 и амплитудой сигнала. Размер лавины вдоль проволочного анода растет с увеличением M от долей мм до веск. мм.

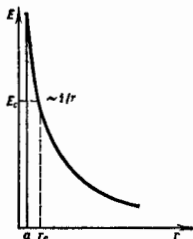


Рис. 3.

При столкновениях образуются также возбужденные атомы, к-рые «высвечиваются» (УФ-излучение) за время $\sim 10^{-8}$ с. Энергия фотонов $h\nu$ почти всегда превосходит работу выхода электронов с поверхности катода, поэтому вырванные (с вероятностью $\sim 10^{-4}$) фотоэлектроны также движутся к аноду, усложняя картину разряда и образуя лавинные серии — последовательно затухающую цепочку импульсов, отстоящих друг от друга на время дрейфа электронов от катода к аноду. *Фотоэлектронную эмиссию* можно ослабить, если в состав газа кроме инертных (Ar, Kr, Xe) ввести многоатомные газы (CH_4 , C_2H_2 , CO_2 и т. д.), поглощающие УФ-излучение. Т. к. электроны поглощают газы и partly со средством к электрону (O_2 , H_2O , галогены), то их в смеси П. с. должно быть мин. кол-во (концентрация $\text{O}_2 \sim 10^{-3}$ см³).

Если пренебречь влиянием на лавину пространственного заряда от положит. ионов, *приближаясь* электронов и фотоэлектронной эмиссией, то

$$M = \exp \int_0^{r_0} \alpha dr,$$

где α — число иониз. соударений электрона на пути 1 см (первый коэф. Таунсенда), α зависит от напря-

жённости поля E , давления p и рода газа. В приближении Роуза — Корфа, где $\alpha = N\delta/K$ (K — характеристика газа, N — плотность газа, δ — энергия электронов),

$$M = \exp(2(KNCr_A V_0)^{1/2} [(V_0/V_0)^{1/2} - 1]).$$

Здесь $C = 2\ln(r_B/r_A)$ — ёмкость счётчика на единицу длины, V_0 — напряжение на электродах, V_c — приращение, соответствующее началу лавины. При

$V_0 \gg V_c$ $M \propto \exp(CV_0)^{1/2}$ (рис. 4). Ввиду статичности природы лавинного процесса V_c не является чёткой характеристикой П. с., поэтому V_c определяется по пересечению прямолинейного участка зависимости $\ln M(V_0)$ с осью абсцисс. Линейная зависимость продолжается до $M \sim 10^4$. При дальнейшем повышении V_0 зависимость перестаёт быть линейной (гл. обр. из-за влияния фотоэлектронной эмиссии и пространственного заряда ионов). Область $M \sim 10^4 - 10^8$ наз. областью

рис. 4. Зависимость коэффициента газового усиления от напряжения.

ограниченной пропорциональности. Большие M могут привести к пробоям (рис. 5). Чтобы не допустить пробоа, применяют гасящие примеси — органич. газы

(CH_4 , пропан, изобутан, C_2H_5OH , метанол и т. п.), к-рые обладают большим сечением поглощения, диссоциации и передачи возбуждения сложной молекуле. Добавка органич. газа стабилизирует процесс газового усиления в широком диапазоне V_0 , хотя само напряжение, необходимое для требуемого M , возрастает.

Формирование сигнала. Вклад в амплитуду импульса за счёт перемещения первичных ионов и электронов мал. Время развития лавины $< 10^{-8}$ с, однако исслед-

ствие того, что электроны в лавине проходят сравнительно малые расстояния (большинство электронов рождаются только на последних стадиях лавины), вклад электронной компоненты в полную амплитуду импульса $\leq 10\%$. Положит. ионы, большинство к-рых расположено от поверхности нити на расстоянии ср. пробега электронов в лавине ($1 \div 5$ мкм), после окончания лавины начинают двигаться к катоду, индуцируя изменение потенциала на нём во времени:

$$\Delta V(t) = \frac{eMn_0}{2C\ln(r_B/r_A)} \ln \left[1 + \frac{2i + V_0}{pa^2\ln(r_B/r_A)} \right].$$

Здесь e — заряд электрона, i — подвижность ионов (см. Подвижность электронов и ионов), n_0 — число первичных ионов. Величина ΔV , вызванная движением ионов, сначала растёт прямолинейно, затем логарифмически; достигает макс. значения ($\Delta V_{\text{макс}} = eMn_0/C$) в момент прихода всех положит. ионов на катод спуски ($1 \div 5 \cdot 10^{-8}$ с с момента образования лавины (рис. 6). Подобные значения от своего максимума импульс достигает за $(1 \div 5) \cdot 10^{-7}$ с, поэтому для получения высокого временного разрешения во входных цепях усилителя стоит дифференцирующие цепи ($\tau = RC$)

или линии задержки. Т. о., в случае траектории частицы (трека), параллельной аноду, удаётся получить импульсы длительностью $\tau < 10^{-7}$ с. При произвольной ориентации трека ширина импульса определяется

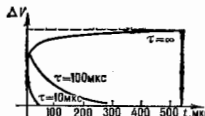


рис. 6. Временное развитие сигнала при различных τ .

разностью во временах дрейфа первичных электронов от начала (А) и конца (В) трека до анода (рис. 2). Эти времена могут достигать $0,1 - 10$ мкс. Такого же порядка и время задержки импульса на выходе П. с. с момента первичной ионизации, что ограничивает возможности использования П. с. в совпадной метод. Энергетическое разрешение. Статистич. флуктуации в кол-ве первичных ионов n_0 , а также флуктуации M «размывают» амплитуду импульсов и определяют предельно достижимое энергетич. разрешение П. с. (эти компоненты приблизительно равны по величине друг другу). Энергетич. разрешение $\Delta E/E$ приближённо выражается соотношением

$$\Delta E/E \approx 0,354 \sqrt{M}.$$

Увеличение разброса амплитуды импульсов могут вызывать конструктивные несовершенства, приводящие к искажению распределения электрич. поля у анода, причём наиб. важным является постоянство r_B по длине П. с., напр. $\Delta r_B \approx 1$ мкм может вызвать разброс амплитуд $\sim 50\%$. Большое влияние на энергетич. разрешение оказывают стабильность V_0 ($\leq 0,05\%$) и чистота газа. Для инертных газов, CO_2 , CH_4 и т. д. не наблюдаются прилипания электронов, но присутствие даже незначит. кол-ва ($< 0,1\%$) электроотрицат. молекул H_2O , CO , O_2 , C_2 и т. д. приводит к значат. ухудшению энергетич. разрешения, т. к. амплитуда импульса становится зависимой от места образования первичных электронов. Добавки нек-рых газов с потенциалом ионизации, меньшим потенциала ионизации осн. газа, могут приводить к уменьшению ср. энергии, затраченной на образование пары ионов, следовательно к улучшению разрешения.

Временные характеристики. Макс. скорость регистрации П. с. зависит от давления и состава газовой смеси и толщины анодной проволоки r_A . При больших скоростях регистрации происходит ослабление электронного лавины, образовавшейся в перекраиваемом пространственном заряде от предыдущей лавины. Это ослабление распределено по случайному закону и вызывает не только уменьшение амплитуды импульсов, но и ухудшает энергетич. разрешение. При $M = 10^4 - 10^5$ макс. скорость счёта составляет $10^5 - 10^6$ с $^{-1}$. Для П. с. практически нельзя указать интервал времени, в к-ром он вообще бы не реагировал на излучение. П. с. для детектирования излучения высокой интенсивности. При этом часто достаточно регистрировать не отд. импульсы, а средний ионный ток с помощью интегрирующих схем.

Применение. Эффективность П. с. к α -частицам, осколкам деления ядер, протонам, электронам и мягким γ -квантам близка 100%. Для регистрации этих частиц в П. с. предусматривают «конца» из тонкой слюды или органич. плёнок. Иногда источник излучения помещается внутри объема П. с. Для регистрации e^- и e^+ с энергиями до 1 МэВ используются П. с. высокого давления (до $p = 150$ атм) в магн. поле. Измерение энергии γ -квантов связано с фотоэффектом в наполняющем газе. Для δ , до $10 \div 20$ кэВ эффективность П. с.

$>80\%$, а для больших ϕ_{γ} необходим Хе (рис. 7; см. Галма-излучение).

При исследовании космических лучей создают большие площади регистрации. Используя большое временное разрешение П. с., удается отличить одну частицу от неск. ливневых пачек, проходящих через П. с.

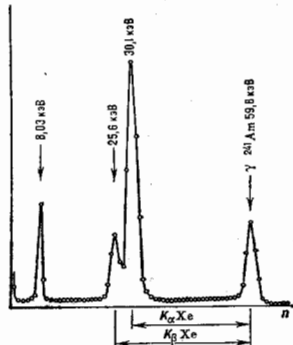


Рис. 7. Амплитудный дифференциальный спектр пропорционального счетчика, наполненного Хе, от частоты характерного рассеяния Си и источника ^{241}Am .

Большие флуктуации в образовании δ -электронов не позволяют получить хорошее энергетич. разрешение от малых долей энергии, оставленных в П. с. быстрой частицей.

Для регистрации нейтронов П. с. заполняют газами ^3He или $^{10}\text{BF}_3$. Нейтроны захватываются ядрами ^3He и ^{10}B с последующим вылетом из них заряж. частиц с энергией порядка 1 МэВ. Ионизация от этих частиц во много раз превосходит ионизацию от γ -квантов, постоянно присутствующих в нейтронных потоках. Т. о., введя амплитудную дискриминацию, удается полностью сделать П. с. нечувствительными к γ -фону. Для нейтронов с энергией $\phi_{\text{п}} \sim 10$ кВб с помощью П. с. можно измерить их энергию по величине смещения пика в амплитудном дифференц. спектре от захвата нейтронов ядром ^3He либо по величине импульсов от ядер отдачи при заполнении счетчика легкими газами H_2 или He (см. Нейтронные детекторы).

П. с. используют для измерения малых уд. активностей. От Гейгера счетчика его выгодно отличает способность выделять моноэнергетич. линии от отд. радионуклидов на фоне непрерывно распределенного фона в широком энергетич. интервале от 1 до 10^6 кВб.

Как спектрометр П. с. уступает полупроводниковым детекторам, однако надежность и простота дают возможность применять его, если не требуется высокоэнергетич. разрешение. П. с. позволяет работать в области энергий $\sim 0,2$ кВб, где полупроводниковый детектор неприемлем. По сравнению со *сцинтилляционными детекторами* П. с. имеет лучшее энергетич. разрешение, меньше шумы, нечувствителен к магн. полю. П. с. работает в диапазоне темп-р $\sim 10^{-4}$ — 10^3 К.

П. с. применяются при изучении *бета-распада* ядер (опеки массы антинейтрино), исследовании тонкой структуры α -спектра, изомерных состояний ядер (см. Измерия ядерная), при обнаружении захвата ядром L -электрона (см. Электронный захват), исследовании слабых конверсионных пиков (см. Конверсия внутренняя) и в др. случаях. Он используется также в астрофизике, археологии, геологии, медицине и т. д. Нек-рое прим. применение основано на зависимости ливневого разряда от напряженности поля у анода и чистоты на-

полняющего газа (контроль диаметра и качества поверхности микроприводов, газоанализатор в газовой хроматографии и т. д.). С помощью усовершенствованного «Лунноход-1» П. с. по рентг. флуоресценции производят элементный анализ вещества поверхности Луны.

Лит.: Rice-Evans P., Spark, streamer, proportional and drift chambers, L., 1974; S a n a d a J. F., Principles of operation of multiple proportional and drift chambers, Gen., 1977; З а н е в с к и я Ю. В., Проволочные детекторы элементарных частиц, М., 1978; S a n a d a J., Growth the avalanche about the anode wire in a gas counter, «Nucl. Instr. and Meth.», 1982, v. 196, p. 23; З а н е в с к и я Ю. В., Basic processes in time-projection like detectors, в кн.: Time projection chamber 1-th workshop, Valsouvier, 1983, N. Y., 1984; Ионизационные измерения в физике высоких энергий, М., 1988.

А. П. Стрелков, Б. Ситар.

ПРОПУСКАНИЕ в оптике — прохождение сквозь среду *оптического излучения* без изменения набора частот составляющих его монохроматич. излучений и их относительных интенсивностей. Различают: на-
правленное П., при к-ром рассеяние света в среде практически отсутствует; диффузное П., при к-ром излучение в осн. рассеивается, а преломление в среде и направленное П. не играют заметной роли; смешанное П. — частично направленное и частично диффузное. Особый вид диффузного П. — равномерно-диффузное П., при к-ром пространственное распределение рассеянного излучения таково, что яркость одинакова по всем направлениям.

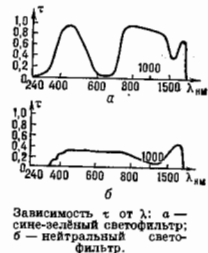
ПРОПУСКАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ среды (τ) — отношение потока излучения Φ , прошедшего через среду, к потоку Φ_0 , упавшему на её поверхность: $\tau = \Phi/\Phi_0$. Чаще всего понятие П. к. используют для световых потоков. Значение П. к. тела зависит как от его размера, формы и состояния поверхности, так и от угла падения, спектрального состава (рис.) и поляризации излучения.

Различают П. к.: для направленного пропускания (среда не рассеивает проходящего через неё излучения), для диффузного пропускания (среда рассеивает всё проникающее в неё излучение), для смешанного пропускания (с частичным рассеянием). П. к. находят по измерениям освещенности и яркости. П. к. определяют в световых измерениях (см. также Фотометрия).

Лит.: Тихоходеев П. М., Световые измерения в светотехнике, 2 изд., М.—Л., 1962; Ш и л т е в И. М. И., Измерения оптического излучения в светотехнике, М., 1980.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ — уменьшение отражения коэффициентов поверхностей оптич. деталей путем нанесения на них непроводящих плёнок, толщина к-рых соизмерима с длиной волны отпач. излучения. Без просветляющих плёнок, даже при нормальном падении лучей, потери на отражение света могут составлять до 10% от интенсивности падающего излучения. В оптич. системах с большим числом поверхностей (напр., в объективах) потери света могут достигать 70% и более. Многократное отражение от преломляющих поверхностей приводит к появлению внутри приборов рассеянного света, что ухудшает качество изображений, формируемых оптич. системами приборов. Эти нежелательные явления устраняются с помощью П. о., что является одним из важнейших применений оптики тонких слоев.

П. о. — результат интерференции света, отражаемого от передних и задних границ просветляющих плёнок; она приводит к взаимному гашению отраженных световых волн и, следовательно, к усилению интенсивности проходящего света. При углах падения, близких к нормальному, эффект П. о. максимален, если толщина



Зависимость τ от λ : а — синие-зеленый светофильтр; б — нейтральный светофильтр.

токовой плёнки равна нечётному числу четвертей длины световой волны в материале плёнки, а *преломленный показатель* (ПП) плёнки n_2 удовлетворяет равенству $n_2 = n_1 n_3$, где n_1 и n_3 — ПП сред, граничащих с плёночной (часто первой средой является воздух). Отражённый свет ослабляется тем сильнее, чем больше разность $n_2 - n_3$; если же $n_2 > n_3$, то интерференция от отражённых от границ плёнки лучей, напротив, усилит интенсивность отражённого света (рис. 1).

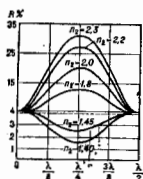


Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения R от выравненной в долих световой волны λ толщины тонкого слоя, нанесённого на подложку из стекла, для различных значений показателя преломления слоя n_2 . Показатель преломления стекла $n_3 = 1,52$, $n_1 = 1$ (воздух).

Изменяя толщину просветляющей плёнки, можно смешать минимум отражения в разл. участки спектра.

Для деталей из стекла с низким ПП П. о. однослойными плёнками недостаточно эффективно. Применение двухслойных просветляющих плёнок позволяет почти полностью устранить отражение света от поверхности детали-подложки независимо от её ПП, но лишь в узкой области спектра. Трёхслойные просветляющие плёнки дают возможность получить равномерное низкое ($\approx 0,5\%$) отражение в широкой спектральной области, напр. во всем видимом диапазоне (рис. 2). Двух- и трёхслойные покрытия используют для П. о., работающих в УФ-области, где из-за низкого значения однослойные покрытия малоэффективны. Наиболее П. о. в

Рис. 2. Зависимость в диапазоне видимого света (400—700 нм) коэффициентов отражения R поверхности стекла с $n_3 = 1,52$ от длины волны света λ : 1 — для непросветлённой поверхности; 2 — для поверхности с однослойной просветляющей плёнкой, показатель преломления которой $n_2 = 1,40$; 3 — то же при $n_2 = 1,23$; 4 — для поверхности с трёхслойной просветляющей плёнкой.

широкой области спектра может быть достигнуто с помощью неоднородных просветляющих плёнок, значение ПП к-рых плавно меняется от n подложки до n окружающей среды. В практически получаемых неоднородных плёнках n меняется ступенчато; ширина спектральной области с низким отражением увеличивается с возрастанием числа «ступенек», приближающим характер изменения ПП к плавному.

Лит. см. при ст. Оптика тонких слоёв. Л. Н. Нагорский, ПРОСВЕТЛЕНИЯ ЭФФЕКТ — увеличение прозрачности среды под действием интенсивных потоков эл.-магн. излучения. В большинстве случаев П. э. обусловлен уменьшением резонансного поглощения в веществе и, следовательно, проявляется лишь в определённой, часто весьма узкой области спектра.

Имеется неск. разл. физ. механизмы просветления. Наиб. распространённый из них — перераспределение населённости уровней молекул вещества под действием резонансного излучения. Простейшим вариантом такого перераспределения является *насыщение эффект*. В этом случае с увеличением интенсивности падающего эл.-магн. излучения населённости нижнего и верхнего уровней резонансного перехода выравниваются, что ведёт к выравниванию скоростей поглощения и вынужденного испускания. В результате поглощаемая мощность стремится к пределу, определяемому только скоростью релаксационных процессов, связанных с передачей энергии окружающей среде (спонтанное

испускание на резонансном переходе, излучат. Φ безызлучат. переходы на др. энергетич. уровни). При дальнейшем увеличении интенсивности поглощаемые уже не увеличивается, а следовательно доля мощности эл.-магн. волны, поглощаемая средой, уменьшается; сред становится прозрачной. Просветление вследствие насыщения имеет место как в поле непрерывного излучения, так и в поле импульсов, длительность к-рых существенно превышает время поперечной релаксации T_2 (см. *Лазерная система*).

В общем случае следствием перераспределения населённости является уменьшение поглощения как эл.-магн. волны, вызывающей это перераспределение (эффект самопросветления), так и др. потоков излучения с частотами, резонансными квантовым переходам, для к-рых результирующая разность населённостей уровней также уменьшается. Напр., насыщению одного из переходов, как правило, сопутствует П. э. на переходах, имеющих общий нижний уровень с насыщенными.

В конденсиров. средах под действием интенсивного излучения при межзонном поглощении происходит опустошение уровней энергии вблизи потолка валентной зоны и заполнение уровней вблизи дна зоны проводимости. В этом случае П. э. имеет характер полосы поглощения в КВ-область. При этом возможно появление даже усиления в нек-ром интервале частот вследствие образования инверсной населённости. Такой механизм характерен, в частности, для цветных стёкол. Именно этим механизмом просветления объясняет С. И. Вавиловым (1923) эффект уменьшения поглощения света уравным стеклом при увеличении интенсивности проходящего света. Сходное поведение поглощения обнаруживается и для электронно-колебат. полос сложных молекул.

Просветление среды в области резонансного поглощения может быть связано со штарковским сдвигом частоты квантового перехода в поле эл.-магн. волны (см. *Штарк эффект*). Кроме того, причиной П. э. могут являться также фотохим. и фотохим. превращения в среде под действием падающего излучения (*фотоионизация, фотодиссоциация, хим. реакция*), приводящие к уменьшению общего числа частиц, поглощающих на заданной частоте.

Иной характер имеет П. э. в поле коротких импульсов, длительность к-рых меньше времён релаксации резонансного перехода. В этом случае возможен т. н. эффект *самоиндуцированной прозрачности*, когда вследствие когерентности взаимодействия энергия, поглощаемая веществом на переднем фронте импульса, полностью возвращается импульсу на его заднем фронте.

Все перечисленные механизмы могут вызывать П. э. и при *многофотонном поглощении*. Кроме того, в этом случае возможно просветление вследствие нелинейной интерференции разл. процессов возбуждения. Напр., возбуждение перехода при трёхфотонном поглощении излучения с частотой ω может быть подавлено действующим в противофазе процессом одифотонного возбуждения в поле излучения на частоте третьей гармоники 3ω . При этом «выключается» как трёхфотонное, так и одифотонное поглощение. Аналогичные эффекты возникают и при двухфотонном поглощении. П. э. такой природы наз. *интерференционным* (иногда — параметрическим) просветлением.

Матем. описание П. э. зависит от механизма просветления, а также от спектральных и временных характеристик излучения. При одифотонном поглощении монокроматич. излучения П. э. описывается ур-нием

$$\frac{dI}{dz} = -k(I)I,$$

где I — интенсивность волны в точке z , $k(I)$ — показатель поглощения, зависящий от интенсивности. Вид ф-ции $k(I)$ определяется конкретным физ. механизмом просветления и характером уширения линий (или

полос) поглощения. Напр., если П. в обусловлен насыщением и линия поглощения ушпрена однородно, то $k(l) = k_0/(1 + \alpha l)$; здесь k_0 — показатель поглощения, k -ый фигурирует в законе Бугера (см. Бугера — Ламберта — Бера закон), α — константа насыщения.

П. з. играет большую роль в *квантовой электронике* и *нелинейной оптике*; ячейки с просветляющими веществом используются для т. н. пассивной модуляции добротности и синхронизации мод *лазеров*, формирования коротких импульсов в лазерных усилителях и т. п. П. з. в газовых средах, помещенных в резонатор лазера и обладающих доплеровски ушпренной линией поглощения на частоте генерации, используется для стабилизации частоты и сужения линий генерации. В *нелинейной спектроскопии* наблюдение П. з. в неоднородно ушпренных линиях поглощения является одним из методов регистрации спектров с высоким разрешением.

Лит.: М а н г ю н Е. А., А ф а н а с ь е в А. М., Об одной возможности «просветления» среды при многоквантовом резонансе, *ЖЭТФ*, 1967, т. 52, с. 1246; А н и я н Я. В., И. и др., К теории сложения частот в резонансных условиях, *Квантовая электроника*, 1976, т. 3, с. 330; К р а с н о в В. В., Ш е п е л ь н и к о в М. С., С о л о м о н о в и ч В. С., Параметрическое просветление среды при резонансном черепашковом взаимодействии, *Письма в ЖЭТФ*, 1980, т. 43, с. 113; см. также лит. при ст. *Нелинейная оптика*, К. Н. Дробачев, ПРОВЕЧИВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП — см. *Электронный микроскоп*.

ПРОСТАЯ ВОЛНА (волна Римана) — волна, каждая точка профиля k -рой распространяется с пост. скоростью u , зависящей от значения волнового поля ψ в этой точке. Такие процессы характерны для нелинейных сред без дисперсии (см. *Волны*). Одномерная П. в. описывается выражением

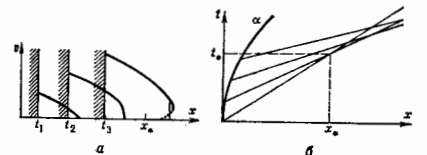
$$\psi = F[x - u(\psi)t], \quad (1)$$

где F — век-рая ф-ция, определяемая начальным условием. На плоскости переменных x, t значение ψ в П. в. сохраняется на прямых

$$x - u(\psi)t = \text{const}, \quad (2)$$

наз. характеристиками. Различным зависимостям $u(\psi)$ соответствуют несколько типов П. в. Если u не зависит от ψ (линейное приближение), то П. в. распространяется без изменения формы. В общем же случае профиль П. в. деформируется.

Пример — движение сжимаемого газа, возбуждаемое поршнем в трубе. В газе существуют две П. в., распространяющиеся со скоростями $u_{\pm} = v \pm c$, где v — скорость частиц, а c — местная скорость звука, зависящая от плотности в данной точке профиля волны. Если поршень выдвигается из трубы, то в ней возникает П. в. разрежения в виде распрямляющихся по координате x переломов давления, плотности, скорости част и т. д. Если же поршень вдвигается в трубу ускоренно с дозвуковой скоростью, то перед ним распространяется П. в. сжатия, k -рая непрерывно сокращается, вплоть до образования участка с бесконечной крутизной профиля, что соответствует пересечению характеристик (рис.). В дальнейшем в волне (1) должна бы-



Взаимная скорости частиц в волне, возникающей при ускоренном движении поршня (а); переломов обозначено положение волновой в последовательные моменты времени. Соответствующий вид (б) характеристикам на плоскости x, t ; x_0 — траектория поршня, x_1 и t_0 — координата и момент образования разрыва.

да бы образоваться неоднородность — «перехлест» или «схлопывание» волны сжатия, но в данном примере это не имеет физ. смысла. На самом деле исходные ур-ния динамики идеального газа, из k -рых следует решение (1), становятся непригодными в области резких изменений состояния, и в результате вместо неоднородности возникает реакий скачок параметров — ударная волна, в k -рой существенную роль играют диссипативные процессы (вязкость и теплопроводность среды). Движение за фронтом ударной волны уже не будет П. в. из-за отражений возмущений от фронта скачка; лишь при достаточно малой его интенсивности отражения пренебрежимо малы (см. *Нелинейная акустика*).

В П. в. возмущения разл. величин являются ф-циями друг друга; эта связь выражается инвариантами Римана J_{\pm} ; в каждой из П. в. опти из инвариантов постоянны. Малые возмущения величин J_{\pm} распространяются в среде только вдоль характеристик (2). В газовой динамике имеются два инварианта Римана $J_{\pm} = u \pm \int (c/\rho) d\rho$. В случае идеального политропного газа, характеризуемого показателем политропы γ , $J_{\pm} = v \pm 2c(\gamma - 1)$.

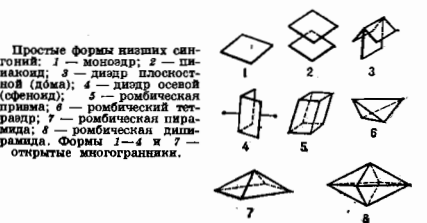
Поватие П. в. применяется и к стационарным двумерным движениям (напр., плоским течениям газа), тогда в ф-лах (1) и (2) вместо x и t аргументами служат координаты x и y .

Движение среды близки границы с областью пост. течения (без разрыва на границе) есть П. в.

Аналогичными свойствами обладают П. в. в др. физ. системах. Однако распространение волны сжатия не всегда приводит к образованию ударной волны в виде монотонной «ступеньки». В общем случае на участках большой крутиины профиля вступает в силу не только диссипация, но и дисперсия, k -рая приводит к появлению осцилляций. Так в ал-магн. системах (плазма, ал-магн. ливних с ферритом) возникает ударный перелом с осцилляциями, а в отсутствие потерь — система солитонов. В ряде случаев образование неоднородности («перехлест») имеет реальный физ. смысл. Так, если u — скорость объектов, движущихся с пост. скоростями без взаимодействия (кинематич. волны), напр. частиц в разреженном луче, то «перехлест» означает просто обгон одним объектов другим.

Ф-лой (1) может быть описано поведение частоты в частотно-модулированной волне, распространяющейся в среде с дисперсией (тогда u — групповая скорость), или компонент волнового вектора в двумерной геометрии оптике; в последнем случае прямые (1) соответствуют лучам, а их пересечение — образованию *каустики* или *флюксов*.

Лит.: Л и а н д у Д. Л., Л и ф ш и ц Е. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; Н у р а т Р. Ф., Р и д и р х с К., Сверхзвуковое течение и ударные волны, пер. с англ., М., 1950; К а д о м ц е в В. Б., Колебательные явления в плазме, М., 1975; Р а б и н о в и ч М. И., П р у б е ц к о в Л. И., Введение в теорию колебаний и волн, М., 1984. Л. А. Астроянский, ПРОСТАЯ ФОРМА КРИСТАЛЛА — совокупность симметрично-эквивалентных плоскостей (гравей многогранника), k -рые можно получить из одной с помощью операций симметрии, свойственных точечной группе



симметрии кристалла. П. ф. к. могут иметь только 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 и 48 граней. Существует 47 П. ф. к., названия к-рых даются по ряду признаков: числу граней, их очертанию и др. (рис. 1).

Различают общие и частные П. ф. к. Частная П. ф. к. получается, если исходная грань параллельна или перпендикулярна осем или плоскостям симметрии или пересекает их под одинаковыми углами. Общая П. ф. к. получается, когда исходная грань задана в общем положении относительно элементов симметрии.

Все грани П. ф. к. при росте кристалла имеют одинаковую скорость роста.

Лит.: Современная кристаллография. т. 1, М., 1979.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИСПЕРСИЯ — см. Дисперсия пространственная.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНВЕРСИЯ — операция зеркального отражения пространственных координатных осей. С инвариантностью теории относительно П. и. в квантовой механике и в квантовой теории поля связано понятие *членности*.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ в оптике — одна из его характеристик, определяющая статистич. связь, корреляцию между параметрами поля в разных точках пространства.

П. к. лазерного пучка определяет статистич. связь между значениями поля не в произвольных точках пространства, а в разных точках поперечного сечения пучка. Вдоль направления распространения лазерного пучка статистич. связь определяется временной когерентностью излучения. Спонтанные шум, возбуждение многих поперечных мод приводит к тому, что поперечная пространственная структура лазерных пучков становится случайной, а их поле излучения оказывается не полностью когерентным в пространстве. Вместе с тем масштаб поперечных корреляций лазерного излучения (поперечный радиус когерентности, радиус корреляции) значительно превосходит соответствующий масштаб нелазерных источников излучения. По величине отношения значений радиуса корреляции к радиусу пучка лазерного излучения различают два предельных случая излучения: многомодового по поперечным индексам и одномодового.

Многомодовые лазерные пучки. В случае возбуждения большого числа N поперечных мод со статистически независимыми фазами пространственная статистика лазерных пучков близка к гауссовой. При этом поперечная пространственная корреляц. ф-ция, ф-ция взаимной когерентности, определяемая выражением

$$\Gamma(r+s, r) = \langle E(r, z, t) E^*(r+s, z, t) \rangle = \sum_{m, n} |A_{mn}|^2 \Psi_{mn}(r, z) \Psi_{mn}^*(r+s, z), \quad (1)$$

похожа на корреляц. ф-цию δ -коррелированного излучения, дифрагированного на круглом отверстии. В выражении (1) $E(r, z, t)$ — комплексная напряженность электрич. поля, действительная часть — $\text{Re}E(r, z, t)$, A_{mn} — амплитуда моды с поперечными индексами m и n , $\Psi_{mn}(r, z)$ — модовая ф-ция, $|\Psi_{mn}(r, z)|^2$ описывает распределение интенсивности моды в поперечном сечении. Направление осей x совпадает с направлением распространения лазерного пучка, двумерный вектор r лежит в плоскости, перпендикулярной оси z . На рис. 1

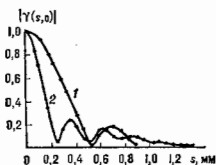


Рис. 1. Модуль степени пространственной когерентности излучения твердотельного лазера для N поперечных мод: 1 — для $N=830$; 2 — для $N=10^4$.

изображена нормированная корреляц. ф-ция (1), т. е. степень П. к.

$$\gamma(r+s, r) = \Gamma(r+s, r) / \Gamma(r, r) \Gamma(r+s, r+s),$$

для случая $r=0$ и разл. числа поперечных мод. Значение радиуса корреляции, определенное, напр., по уровню 0,5 от макс. значения $|\gamma(s, 0)|$, равного единице, существенно зависит от геометрии резонатора и числа поперечных мод N . Так, для многомодовых лазерных пучков, возбуждаемых в резонаторе с плоскими прямоугольными зеркалами, радиус корреляции $r_{кл} \approx d/\sqrt{N}$, где $2d$ — размер зеркала вдоль измеренного направления. В случае сферич. резонатора с круглыми зеркалами $r_{кл} \approx \sqrt{2a(z)} / \sqrt{N}$, где $a(z)$ — радиус вышней моды на расстоянии z от перетяжки пучка. Последняя зависимость радиуса корреляции получила эксперим. подтверждение. Кроме того, значение радиуса корреляции $r_{кл}$ увеличивается к краю лазерного пучка, т. е. многомодовые лазерные пучки, возбуждаемые в сферич. резонаторах, являются статистически неоднородными. Для числа мод $N=10^4$ отношение $r_{кл}/a \approx 10^{-2}$, поэтому, если радиус пучка составляет 1–10 мм, радиус корреляции оказывается равным 10–100 мкм. При наличии неоднородностей в активной лазерной среде даже для плоского резонатора более адекватной оказывается модель сферич. резонатора.

Одномодовые лазерные пучки; предельная П. к. и стохастическое блуждание пучка. При генерации лишь осн. поперечной моды TEM_{00} (индексы $m=n=0$) усиление в лазере достаточно для компенсации потерь, состоящих из потерь в среде, на излучение и дифракционных. Однако этого усиления недостаточно для компенсации потерь на высших модах, поскольку с увеличением номера поперечного индекса m и (или) n дифракц. потери растут. Спонтанное излучение усиливающей среды не только является затравкой для возбуждения осн. моды, но и поддерживает на определенном уровне интенсивность подпороговых высших мод. Вследствие излучения последних П. к. одномодовых лазерных пучков не является полной. Но в пределах ширины пучка степень П. к., напр. для излучения гелиево-неоновых лазеров, отличается от 1 не более чем на $10^{-4} - 10^{-5}$ (рис. 2). Осн. влияние на предельную степень П. к. моды TEM_{00} оказывают ближайшие подпороговые

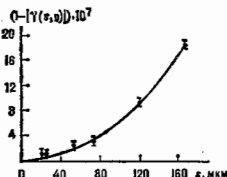


Рис. 2. Зависимость $1 - |\gamma(s, 0)|$ в одночастотном режиме генерации лазера $LiF:LiBr$ ($N_s = 833$ мод; точки — экспериментальные данные, кривая — теоретическая).

высшие моды, т. е. моды с поперечными индексами $m=0, n=1$ и $m=1, n=0$. Для мод сферич. резонатора

$$\Psi_{00}(s) = \exp(-s^2/a_0^2), \quad \Psi_{10}(s) = 2(s/a_0) \exp(-s^2/a_0^2)$$

и значений $r(0,0), s(1,0)$ степень П. к.

$$\gamma(s, 0) = 1 - \frac{1}{2} \epsilon f(s) = 1 - 2\epsilon (s/a_0)^2, \quad (2)$$

где

$$\epsilon = \frac{|\langle A_{10}(t) \rangle|^2}{|A_{00}(t)|^2}, \quad f(s) = \sqrt{\frac{2}{10}} \frac{\Psi_{10}(s)}{\Psi_{00}(s)}.$$

Величина ϵ представляет собой отношение макс. интенсивности подпороговой моды к осн. моды:

$$\epsilon = \frac{\alpha(\omega_0)(1-R)^2 h \omega_0}{8(q_{10} - q_{00})P} \cdot \frac{N_1}{N_0 - (g_1/g_0)N_1}. \quad (3)$$

Здесь $\alpha(\omega_0)$ и u — коэф. усиления и групповая скорость на частоте ω_0 осн. моды, L — Планка постоянная, $R_{\text{диф}}$ — дифракц. потери на соответствующей моде, R — коэф. отражения по амплитуде выходного зеркала; N_1, N_2 — населенности нижнего и верхнего уровней усиливающей среды, g_j — параметр вырождения уровней, P — мощность излучения через выходное зеркало. Из (3) видно, что значение ξ обратно пропорц. разности дифракц. потерь ($g_{10} - g_{00}$), излучаемой мощности P , равности населенностей рабочих уровней.

Др. интерпретация следствия подподрогового возбуждения высших мод (т. е. не полной П. к.) — стохастич. блуждание центра осн. моды. Дисперсия этого блуждания

$$\sigma^2 = (\delta s)^2 = \xi \sigma g^2. \quad (4)$$

При радиусе пучка $a_0 = 0,3$ мм значение $\sigma = 0,5$ мкм (рис. 2). С ростом мощности излучения величина σ уменьшается как $P^{-1/2}$ и может быть ≈ 10 мкм.

С неполной П. к. можно также связать естеств. угл. расходимость θ_e , обусловленную спонтанным излучением лазера:

$$\langle \theta_e^2 \rangle = -k_0^2 d^2 \gamma(s, 0) / ds^2 \Big|_{s=0}. \quad (5)$$

При этом дисперсия случайного блуждания

$$\sigma^2 = \frac{1}{4} (k_0 a_0)^2 \langle \theta_e^2 \rangle. \quad (6)$$

Соотношения (5), (6) дают общую связь между неполной П. к., стохастич. блужданием и естеств. угл. расходимостью лазерного пучка. Выражения (4), (6) в совокупности с (3) можно рассматривать как некий пространственный аналог ф-лы Шавлова — Тауса для естеств. ширины линии односточного лазерного излучения.

Неполная П. к. однодмодового лазерного пучка (или естеств. угл. расходимости, или стохастич. блуждание), обусловленная принципиально не устранимыми флуктуациями — спонтанным излучением лазера, влияет, очевидно, на разрешающую способность и информативность систем оптич. записи и считывания информации.

Лит.: А. Шавлова С. А., Дьяков Ю. Е., Черник А. С., Введение в статистическую радиофизику и оптику, М., 1981; Аджманов С. А., Черник А. С., Беллинский А. В., Предельная пространственная когерентность лазерного излучения, «УФН», 1993, т. 163, № 3.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РЕШЕТКА — бесконечная совокупность точек (узлов), расположенных по вершинам равных параллелепипедов, сложенных равными гранями и заполняющих пространство без промежутков; простейшая схема строения кристалла. Параллелепипеды П. р. преобразуются друг в друга преобразованиями на группы конечных переносов (трансляций). См. *Брэгг решетка*.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ — воздействие на структуру потока излучения с целью придания желаемых свойств (напр., малой расходимости) либо обработки переносимой этим потоком информации (см. *Оптическая обработка информации*). В оптич., ИК- и ближнем УФ-диапазонах используются фокусирующие элементы для создания пространственных фильтров, к-рые осуществляют эфф. и равнообразное управление пространственным спектром излучения. В рентг. и др. КВ-диапазонах фокусирующие линзы в зеркалах отсутствуют, для выделения узкого коллимированного пучка в этих диапазонах применяются наборы последовательно установленных экранов с расположенными на одной линии отверстиями в них.

Чаще всего П. ф. сводится к преобразованию фурье-спектра двумерного распределения поля по сечению светового пучка. Кроме разложения волны в фурье-спектр применяются и иные виды разложений (напр., с помощью преобразования Фуреля), но значительно

Фурье-фильтрация используется во многих традиц. методах исследования объектов, непосредств. наблюдение к-рых по тем или иным причинам невозможно или затруднено. Стандартная схема оптич. систем с фурье-фильтрацией приведена на рис. Ближний к параллельному пучок света от лазера либо от иного малого источника света 1, помещенного в фокальной плоскости коллимирующей линзы 2, проходит через исследуемый объект 3 и попадает в фурье-фильтр, состоящий из двух положительных софокусных линз 4 и 6 и расположенного в их общей фокальной плоскости фазово-амплитудного транспаранта 5. В фокальной плоскости линзы 4 формируются фурье-образ распределения поля перед

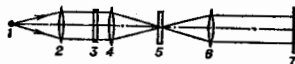


Схема пространственной фильтрации: 1 — источник света; 2 — коллимирующая линза; 3 — исследуемый объект; 4 и 6 — софокусные линзы; 5 — транспарант; 7 — плоскость изображения объекта.

этой линзой (см. *Матричные методы* в оптике). Транспарант осуществляет необходимое воздействие на спектр, линза 6 — обратное преобразование Фурье. Перевернутое изображение объекта находится в плоскости 7 на расстоянии 4f от него, где f — фокусное расстояние линз 4, 6 (для простоты считаем их идентичными).

Если объект является самосветящимся (плазма, продукты взрыва) и его зондик осуществляется с помощью излучения источника 1, то для уменьшения засветки изображения собств. светом объекта используют транспарант в виде непрозрачного экрана с отверстием на оси, пропускающим весь поток зондирующего излучения. Для наблюдения мелких рассеивающих свет частиц и оптич. неоднородностей в прозрачных средах используют т. н. теневые методы, при к-рых перекрывают центр. часть сечения фокальной плоскости. В результате до системы регистрации доходит лишь рассеянный свет и распределение освещенности в плоскости 7 соответствует картине распределения неоднородностей (источников светорассеяния) в плоскости объекта.

Намного большая чувствительность к малым фазовым возмущениям достигается с помощью метода *фазового контраста* (метода Цернике). Прозрачный объект, являющийся источником возмущений, освещается идеальной плоской волной; после его прохождения распределение комплексной амплитуды волны приобретает вид $u \approx e^{i\varphi}$, где φ — зависящие от поперечных координат фазовые отклонения, к-рые и подлежат регистрации. Транспарант представляет собой прозрачную пластинку с таким утолщением (либо выемкой) в малой приосевой зоне, что между светом, проходящим через эту зону и через остальную часть сечения, создается разность хода $\lambda/4$.

При малых фазовых отклонениях φ величина $e^{i\varphi} \approx \approx 1 + i\varphi$; первому члену разложения соответствует плоская волна ($c \equiv \text{const}$), фокусируемая линзой в центр. часть транспаранта, второму — рассеянный свет, проходящий мимо центр. зоны. Введение фазового сдвига между этими компонентами приводит к тому, что после фильтра $u \approx 1 + e^{i\pi/2} \varphi = 1 - \varphi$, $|u|^2 \propto (1 - \varphi)^2 \approx 1 - 2\varphi$. Т. о., фазовые искажения превращаются в вариации интенсивности, причём в отличие от теневых методов реакция здесь является линейной.

Если, оставив транспарант там же, поместить в плоскости 7 плоское зеркало, свет на обратном пути будет подвергаться аналогичному преобразованию и при подходе к объектной плоскости окажется, что $u \propto 1 + e^{i\varphi} \times \times i\varphi = 1 - i\varphi \approx e^{-i\varphi}$, т. е. реализуется *обращение волнового фронта*.

П. ф. применяется также для улучшения качества изображений, распознавания образов, осуществления их сортировки и т. п. Напр., используя транспарант в виде непрозрачного экрана с щелью, можно избавиться от полюс на изображении, вызванных строчной разверткой; частично или полностью подавив низкие пространственные частоты, можно осуществить контурирование изображений. Реализуемы фильтры, резко снижающие дефекты изображения, вызванные расфокусировкой при фотографировании; фильтры, отмечающие яркие точки на плоскости изображений местоположением к-л. заданной буквы в служащем объектом печатанном тексте, и т. д. Следует, однако, иметь в виду, что распознавание образов резко затрудняется, если неизвестны заранее масштабы и ориентировка изображений соответствующих объектов.

При высококонтрастных источниках света успешно используются афф. фильтры самого разного назначения, изготовленные на основе методов голографии (см. Голографическое распознавание образов). Можно создать фильтры, воздействующие и на амплитуду, и на фазу отд. фурье-компонент с участием голограмм, осуществляющих лишь амплитудную модуляцию падающего на них света (метод Логта).

Реально производимая П. ф. нередко заменяется эквивалентной ей матем. обработкой результатов измерений световых полей (при необходимости — с использованием рассчитанных откорректированных изображений).

Лит.: Гудман Д. ж., Введение в фурье-оптику, пер. с англ., М., 1970; Передача и обработка информации голографическим методом, М., 1978; Ку Ф. Т. С., Введение в теорию дифракции, обработку информации и голографию, пер. с англ., М., 1979. Ю. А. Аманцев.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЧАСТОТА — аналог обычной частоты при задании фаз. величин в виде ф-ции не времени, а координаты; имеет размерность см⁻¹. Понятие П. ч. очень часто используется в оптике для оценки способности систем оптич. информации передавать информацию об объекте.

Для примера рассмотрим наиб. простой случай одностороннего пропускающего объекта — дифракц. решётки, ф-ция пропускания к-рой

$$\tau(\xi) = \tau_0 + \cos \frac{2\pi}{T} \xi, \quad (*)$$

где ξ — координата в плоскости объекта, τ_0 — ср. амплитудное пропускание, τ — амплитуда изменения пропускания. При заданных значениях τ_0 и τ изменение свойств объекта можно однозначно задать, определив период изменения ф-ции $T = d = 1/f$. Здесь T — период ф-ции, равный расстоянию между ближайшими точками объекта в направлении ξ , в к-рых амплитудное пропускание одинаково, f — величина, обратная пространственному периоду, наз. П. ч. При описании дифракц. решётки с помощью П. ч. легко оценивается, напр., требуемая апертура объектива $D = 2\lambda/z$ (z — расстояние от решётки до главной плоскости линзы). Дифракц. решётка — синусоидальный одномерный объект; несинусоидальные одномерные объекты характеризуются набором (спектром) П. ч. В более общем двумерном случае объект можно рассматривать как результат наложения синусоидальных решёток, ориентированных произвольно. Тогда распределение поля $u(x, y)$ по сечению светового пучка (x, y — поперечные декартовы координаты)

$$u(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) \exp[2\pi i(f_x x + f_y y)] df_x df_y,$$

где $F(f_x, f_y)$ — фурье-образ этого распределения,

$$F(f_x, f_y) = \iint u(x, y) \exp[-2\pi i(f_x x + f_y y)] dx dy.$$

f_x, f_y и есть пространственные частоты. Лит. см. при от. Пространственная фильтрация.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЧЕТНОСТЬ — то же, что Р-чётность.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СИММЕТРИЯ — симметрия пространственно-временного континуума, в к-ром протекают физ. процессы. В основном П.-в. с. — это следствие изотропии и однородности пространства-времени, они проявляются в инвариантности (ковариантности) физ. систем, полей и ур-ний движения относительно преобразований координат, отвечающих вращениям или трансляциям вдоль направлений пространственно-временных осей. В квантовой механике и квантовой теории поля (КТП) существенную роль играют дополнительные, дискретные симметрии, связанные с отражениями пространственно-временных осей. С П.-в. с. связаны сохранения законов: из свойства изотропии пространства следует сохранение угл. момента, из однородности пространства-времени — сохранение 4-импульса. Дискретные симметрии приводят к сохранению чётности. Законы сохранения чётности являются приближёнными, но нет никаких указаний на приближённый характер непрерывных П.-в. с.

Группа П.-в. с. наз. Пуанкаре группой. Её генераторами в КТП являются 6 компонент антисимметричного тензора момента кол-ва движения $M_{\mu\nu}$ и 4 компонента вектора импульса P_μ ($\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$).

В КТП существует теорема, возможность расширения пространственно-временного континуума за счёт включения 4N дополнительных веществ. антикоммутирующих координат, при этом группа Пуанкаре расширяется до группы простой ($N = 1$) или расширенной ($1 < N < 8$) суперсимметрии (см. Суперсимметрия, Суперразрешения). Однако неясно, реализуется ли в природе эта возможность.

Существует глубокая связь между П.-в. с. и внутренними симметриями. Наб. ярким примером такой связи является строгое сохранение СРТ-чётности (при приближённом сохранении С- и РТ-чётности; см. Теорема СРТ).

М. В. Терехтеев, **ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КВАНТОВАНИЕ** — то же, что квантование момента количества движения; дискретность возможных его пространственных ориентаций относительно произвольно выбранной оси. См. Квантовая механика.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ОДНОРОДНАЯ КВАДРУПОЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА — фокусировка пучков заряд. частиц в линейных ускорителях или каналах транспортировки, обусловленная чередованием во времени направления квадрупольно-симметричного электрич. поля. Практич. разработка структур с П.-о. к. ф. началась в СССР в 1970 (за рубежом широко развинулась с 1979). До 70-х гг. в линейных ускорителях и каналах транспортировки была известна фокусировка частиц со аналогичной пространственно-периодич. структурой, состоящей из статич. квадрупольных линз. Один из возможных пространственно-периодич. типов структуры показан на рис. 1 (u — пост. напряжение на электродах). В отличие от пространственно-периодич. фокусирующих структур, канал с П.-о. к. ф.

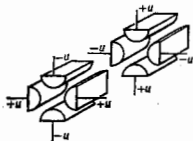


Рис. 1. Пространственно-периодический квадрупольный фокусирующий канал.

в принципе представляет собой длинную четырёхкратную линзу на квадрупольной симметрии, на к-рую подано 4U-напряжение (рис. 2). Заряд. частицы, движущиеся вдоль продольной оси симметрии, испытывают действие поперечного электрич. поля с черед. знаком градиента. Это приводит к эффекту квадруполь-

вой фокусировки в пространственно-однородной структуре. Направление сил, действующих на движущуюся частицу, в каждой из координатных плоскостей меняется по длине пути, соответствующей половине периода ВЧ-поля. Длина периода фокусировки составляет

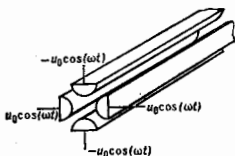


Рис. 2. Пространственно-однородный квадратный фокусирующий канал.

$\beta\lambda$, где $\beta = v/c$, v — скорость частицы, λ — длина волны электрич. поля в свободном пространстве. Макс. градиент фокусирующего поля в первом приближении равен $2u_0/a^2$, где u_0 — амплитуда ВЧ-напряжения, a — мин. расстояние от оси до электрода.

В канале с П.-о. к. ф. может быть создана продольная ускоряющая компонента электрич. поля за счёт периодич. изменения потенциала вдоль продольной оси симметрии с периодом $\beta\lambda$, что позволяет использовать этот тип фокусировки в линейном ускорителе. Необходимое изменение потенциала возникает при периодич. модуляции расстояний с периодом $\beta\lambda$ между противоположными электродами, если фаза модуляции для электродов с противоположными полярностями сдвинута на 180° . Другими словами, когда расстояние между электродами, лежащими в горизонтальной плоскости, возрастает, то расстояние между электродами, лежащими в вертикальной плоскости, уменьшается. Амплитуда разности потенциалов на периоде ускорения $\beta\lambda/2$ в первом приближении составляет $u = 2Au_0$, где

$$A = (m^2 - 1) [I_0^2(ka) + I_0^2(mka)],$$

m — отношение макс. расстояния от оси симметрии до ближайшей точки электрода к минимальному, $k = = 2\pi/\beta\lambda$, I_0 — модифициров. функция Бесселя нулевого порядка. При модуляции формы электродов и заданном мин. расстоянии от оси ускорителя сила фокусировки снижается примерно на 40–50%; появляется, как и при пространственно-периодич. фокусировке (см. Квадратный фокусировка), высокочастотный дефокусирующий эффект.

В линейных ускорителях с П.-о. к. ф. сила фокусировки не зависит от энергии частиц и от их фазы относительно ВЧ-поля. Все частицы сфокусируются примерно одинаково. Это позволяет спец. образом использовать эффект автофокусировки. В непрерывном пучке на входе ускорителя струйка частиц следует вилотовую друг за другом, но по мере роста скорости частиц они раздвигаются, сохраняя приблизительно неизменные геометр. размеры и, следовательно, пост. плотность пространственного заряда. Захват частиц в режим ускорения может достигать 95–97%, что вдвое выше лучших значений этого параметра в др. известных структурах. Линейные ускорители с П.-о. к. ф. могут работать при весьма низких нач. скоростях частиц. Но при малых нач. скоростях сохраняется высокое предельное значение тока пучка.

Эффект П.-о. к. ф. используется в инжекторах протонных и тяжёлых ионовных синхротронов. Использование П.-о. к. ф. в линейных ускорителях дало возможность получить сильноточные пучки ионов, применяемые в ряде новых технологий: в создании высокопоточных нейтронных генераторов для радиан. материаловедения, связанного с проблемами термоядерных реакторов; формирования сильноточных пучков протонов для электроодерного метода «наработки» ядерного го-

рючего, для уничтожения радиоактивных отходов АЭС; создания линейных ускорителей сверхтяжёлых мало-зарядных ионов для кованного термоядерного синтеза, создания малогабаритных генераторов мощных атомных пучков. Осн. трудности создания линейного ускорителя были связаны с низким коэф. захвата частиц и режим ускорения и с высокой энергией ионизции, при к-рой электростатич. предускорители терли электрич. прочность.

В линейных ускорителях протонов и ионов Н⁺ используются частоты в диапазоне 80–450 МГц. Для создания ВЧ-напряжения на четырёхпроводной линии в этом диапазоне применяются четырёхкамерные объёмные резонаторы разл. конструкции с продольной маг. волной.

В зависимости от типа иона и требуемых параметров пучка в линейных ускорителях тяжёлых ионов используются частоты в диапазоне 6–30 МГц. Разработаны резонансные структуры в виде четвертьволновых отрезков коаксиальной линии с разрезным внутр. стержнем; разработаны также резонансные структуры, содержащие сосредоточенные индуктивности.

В модулиров. четырёхпроводных линиях применяются преим. дилатирч. электроды с периодически меняющимся диаметром или плоские электроды перем. длины, каждый на к-рых ограничен в сечении полукругом с постоянным по всей длине радиусом.

Область устойчивости поперечных колебаний частиц по координатам и импульсам на входе канала с П.-о. к. ф. изменяется с частотой перем. фокусирующего поля. Реализованы разл. методы согласования статич. пучка на входе канала с перем. областью устойчивости.

Лит.: К а ч и к я И. М., Теория линейных резонансных ускорителей, М., 1982, с. 131; К л е й н П. H., Development of the different RFQ accelerating structures and operation experience, «IEEE Trans. Nucl. Sci.», 1983, т. NS-30, № 4, p. 3313.

И. М. Качиченый.

ПРОСТРАНСТВЕННОПОДОБНЫЙ ВЕКТОР — в частной (специальной) и общей теории относительности — четырёхмерный вектор, сумма квадратов пространственных компонент к-рого больше квадрата его временной компоненты. П. в., имеющий начало в к.-н. точке четырёхмерного пространства-времени, лежит вне внутр. полостей светового конуса с вершиной в данной точке. Всегда существует система отсчёта, в к-рой временная компонента П. в. обращается в нуль, и у него остаются только пространственные компоненты. В Минковского пространстве-времени с метрич. тензором $(+1, -1, -1, -1)$ квадрат длины П. в. A отрицателен:

$$(A)^2 = A^4 A^4 = (A^0)^2 - A^2 < 0, \quad (\mu = 0, 1, 2, 3).$$

Здесь A^0 — временная, $A^i (i = 1, 2, 3)$ — пространственные компоненты 4-вектора $[A = (A^0, A^1, A^2, A^3)]$. См. Относительность теории, Тетраплетные.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРУППЫ СИММЕТРИИ — группы симметрии, описывающие атомные структуры кристаллов. Представляют совокупность операций симметрии, включающую операции симметрии точечных групп симметрии и трансляции (параллельный перенос). Существует 230 П. г. с. Выведены в 1890 Е. С. Фёдоровым в независимом А. Шёнфлисом (A. Schoenflies), названы фёдоровскими группами. См. также Симметрия кристаллов.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИММЕТРИИ — симметрии четырёхмерного пространства-времени, в к-ром осуществляются физ. явления. С однородностью и изотропностью пространства-времени связана инвариантность фундам. физ. законов относительно трансляций и вращений четырёхмерных систем координат, в к-рых эти законы формулируются. Группа таких преобразований наз. Пуанкаре группой. Подгруппа вращений в пространстве-времени наз. группой Лоренца преобразований. Следствием указанных симметрий являются законы сохранения энергии-импульса и угл. момента.

Существует также симметрия относительно отраже-

ний осей четырёхмерной системы относительно начала координат. В отличие от трансляций и вращений, эта симметрия не является точной. Соответствующий ей закон сохранения чётности (см. Чётность нарушается в слабых взаимодействиях).

В квантовой теории поля (КТП) существует глубокая, по ещё не понята до конца связь между П. с. и *внутренними симметриями*. Наиб. ярким примером такой связи являются теорема СРТ и тот факт, что СР-чётность сохраняется с большей точностью, чем пространственная чётность (Р-чётность). Другой пример: некие модели КТП формулируются в пространстве с числом измерений, большим четырёх. При этом многие внутр. симметрии в «нашем» четырёхмерном пространстве являются следствием П. с. в пространстве большего числа измерений.

М. В. Терентьев.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗАРЯД (объёмный заряд) — электрич. заряд q , распределённый в объёме V так, что его плотность $\rho = dq/dV$ конечна. П. з. определяет пространственное распределение потенциала Φ и напряжённости поля E согласно *Пуассона уравнению*, к-рое для среды с постоянной диэлектрич. проницаемостью можно записать так: $\Delta\Phi = \text{div}E = -4\pi\rho$. П. з. образуется, когда локальные концентрации положит. и отрицат. носителей заряда взаимно не компенсируются, а это в свою очередь связано с различием в механизмах образования заряд. частиц разного знака и различием в скоростях ухода таких частиц на границе объёма. Плотность П. з. $\rho = e \sum Z_i n_i$, где n_i — концентрации и $Z_i e$ — заряд носителей данного i -го сорта; Z_i имеет знак носителя, так что для электрона или одновалентного отрицат. иона $Z_i = -1$.

Поскольку свободные электрич. заряды не могут образовывать объёмную статически равновесную систему (см. *Ирришю теорема*), реальные условия возникновения П. з. связаны обычно с процессом прохождения тока. П. з. образуются вблизи электродов при прохождении тока через электроды, на границе двух проводников с разл. проводимостью, в вакууме вблизи вытравливающего электроны катода, в газовом разряде вблизи электродов, стенок, в местах с резким изменением поперечного сечения. Образованию П. з. способствует наличие в среде носителей заряда с разными коэф. диффузии. Напр., в плазме большой коэф. диффузии электронов по сравнению с положит. ионами приводит к возникновению избыточного положит. заряда и, как следствие, — направленного из плазмы поля. Под действием этого поля диффузия электронов замедляется, в результате макроскопич. диффузионные потоки ионов и электронов выравниваются (*амбиполярная диффузия*). П. з. экранирует и внешнее электрич. поле, приложенное к плазме, препятствуя его проникновению в плазму. Вследствие такой экранировки характерная глубина проникновения электрич. поля в плазму порядка *дебаевского радиуса экранирования*. Этот эффект определяет также значение *диэлектрической проницаемости* плазмы, к-рое меньше соответствующего значения в вакууме.

Образование П. з. определяет распределение потенциала и вид *гольт-амперных характеристик* при прохождении тока в вакууме и отд. областях газового разряда. Плотность П. з. зависит от плотностей тока j_i и скоростей u_i соответствующих носителей заряда. Т. к. ток направлен от большего потенциала к меньшему, то, понимая под j_i абс. величину плотности тока и учитывая знак u_i , можно написать $\rho = -\sum j_i/u_i$. При движении электронов в вакууме с нулевой нач. скоростью на катоде скорость u_i задаётся пройденной разностью потенциалов, так что для одномерной задачи

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = -4\pi \left(\frac{2e\Phi}{m} \right)^{-1/2},$$

где m — масса электрона. Интегрирование этого ур-ния при нач. условиях $\Phi = 0$ и $E = 0$ при $x = 0$ приводит к зависимости $\Phi \propto x^{3/2}$ и к вольт-амперной характери-

стике, определяемой законом $3/2$ (см. *Ленгмюра формула*).

Решение аналогичной задачи для положит. ионов в газе зависит от характера движения ионов (см. *Поведенность электронов и ионов*). В слабых полях и $\propto E$, в сильных и $\propto E^{3/2}$. В первом случае получается $j \propto \Phi^2$, во втором $j \propto \Phi^{3/2}$. Поля, создаваемые П. з. в газе, определяют многие важные свойства разряда (временной код развития разряда, образование *стриаторов*, плазменные колебания и пр.). Образование П. з. влияет на нарастание электронной лавины, распространяющейся в газе высокого давления. В этом случае при пренебрежении определяющего числа зарядов в лавине ($\sim 10^8$) П. з. ионов, поле к-рого направлено противоположно внеш. электрич. полю, частично экранирует его и тем самым снижает эффективность размножения носителей в лавине и уменьшает скорость её распространения (см. *Лавина электронная*).

П. з., возникающий при распространении пучка электронов через вакуум, служит причиной угл. расходимости пучка. В результате магн. взаимодействия электронов пучка эффект расходимости с ростом энергии электронов пучка уменьшается. При распространении электронного пучка в газе расходимость также уменьшается в связи с экранирующим действием П. з. положит. ионов.

Поскольку ρ определяется алгебраич. суммой зарядов разных носителей, наличие в объёме зарядов противоположных знаков может привести к частичной или полной компенсации П. з. Примерами могут служить плазма, в к-рой концентрации ионов и электронов почти равны, и прикатодная область в разряде с накалённым катодом, где положит. ионы практически компенсируют заряд электронов, благодаря чему падение потенциала в таком разряде невелико и почти не зависит от тока.

Ур-ние Пуассона, применяющееся в указанных выше случаях, предполагает, что П. з. распределён непрерывно по всему рассматриваемому объёму. В действительности поле П. з. складывается из полей отд. носителей. Поэтому приведённые зависимости Φ и E есть величины, усреднённые для областей, линейные размеры к-рых велики по сравнению со средним расстоянием между носителями, т. е. с длиной порядка $(\sum n_i)^{-1/2}$. Хаотически меняющиеся во времени локальные поля должны вычисляться непосредств. наложением полей отд. носителей с учётом их статистич. распределения.

Лит.: Капцов Н. А., Электрические давления в газах и вакууме, 2 изд., М.—Л., 1956; Петер Г., Электронные лавины и пробой в газах, пер. с англ., М., 1968; Лозанский Я. Д., Фирсова О. В., Теория искр., М., 1975; Райвер Ю. П., Физика газового разряда, М., 1987.

Л. А. Сена, А. В. Есевич,

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ в ф и з и к е определяются в общем виде как фундам. структуры координат материальных объектов и их состояний: система отношений, отображающая координатно-существующих объектов (расстояния, ориентация и т. д.), образует пространство, а система отношений, отображающая координатно сменяющихся друг друга состояний или явлений (последовательность, длительность и т. д.), образует время. П. и в. являются организующими структурами реал. урвовой физ. познания и играют важную роль в межуровневых взаимоотношениях. Они (или сопряжённые с ними конструкции) во многом определяют структуру (метрическую, топологическую и т. д.) фундам. физ. теории, задают структуру эмпирич. интерпретации и верификация физ. теорий, структуру операциональных процедур (в основе к-рых лежат фиксации пространственно-временных совпадений в измерит. актах, с учётом специфики используемых физ. взаимодействий), а также организуют физ. картины мира. К такому представлению ведёт историч. путь концептуального развития.

В наиб. архаичных представлениях П. и в. вообще не вычленились из материальных объектов и процессов природы (в к-рой достаточно мирно уживались как естественные, так и сверхъестественные персонажи): разл. участки территории обитания наделались разл. доминит. и отрицат. качествами и силами в зависимости от присутствия на них разл. сакральных объектов (захоронения предков, тотемы, храмы и т. д.), а каждому движению было сопоставлено своё время. Время также членилось на качественно разл. периоды, благоприятные или зловередные по отношению к жизнедеятельности древних соитумов. Ландшафт и календарные даты выступали запечатлённым мифом. В дальнейшем развитии мифологии картина мира стала функционировать в рамках циклич. времени; будущее всегда оказывалось возрождением сакрального прошлого. На страже этого процесса стояла жёсткая идеология (обряды, запреты, табу и т. д.), принципами к-рой нельзя было поступиться, ибо они были приваны не допускать никаких новаций в этот мир вечных повторений, а также отрицали историю и историч. время (т. е. линейное время). Такие представления можно рассматривать как архаичный прообраз модели неоднородного и неэвтропного П. и в. Учитывая, что развитая мифология пришла к представлению о членении мира на уровни (первоначально на Небо, Землю и Подземный мир, с последующим вычлением «стоякой структуры» двух крайних уровней, напр. седьмое небо, круги ада), можно дать более ёмкое определение П. и в. мифологии: картины мира: циклич. структура времени и многолобный изоморфизм пространства (Ю. М. Лотман). Естественно, это всего лишь совр. реконструкция, в к-рой П. и в. уже абстрагированы от материальных объектов и процессов; что же касается человеческого познания, то оно и подобному абстрагированию пришлось не в архаичной мифологии, а в рамках последующих форм обществ. сознания (монотеистич. религий, натурфилософии и т. д.).

Начиная с этого момента, П. и в. получают самостоят. статус в качестве фундам. фона, на к-ром разворачивается динамика природных объектов. Такие идеализированные П. и в. часто даже подвергались обожествлению. В античной натурфилософии происходит рационализация мифо-религиозных представлений: П. и в. трансформируются в фундам. субстанции, в первооснову мира. С этим подходом связана субстанциальная концепция П. и в. Таковы, напр., пустота Демокрита или топос (место) Аристотеля — это разл. модификации концепции пространства какместилища («ящич без стенок» и т. д.). Пустота у Демокрита заполнена атомич. материей, а у Аристотеля материя континуальна и заполняет пространство без разрывов — все места заняты. Т. о., аристотелево отрицание пустоты не означает отрицания пространства какместилища. Субстанциальная концепция времени связана с представлением о вечности, некоей неизменяющейся абс. длительности. Частное эмпирич. время рассматривалось как движущийся образ вечности (Платон). Это время получает числовую оформленность и метрируется с помощью вращения неба (или иных, менее универсальных, периодич. природных процессов) в системе Аристотеля; здесь время выступает уже не как фундам. субстанция, а как система отношений («раньше», «позже», «одновременно» и т. д.) и реализуется реляционная концепция. Ей соответствует реляционная концепция пространства как системы отношений материальных объектов и их состояний.

Субстанциальная и реляционная концепции П. и в. функционируют соответственно на теоретич. и эмпирич. (или умозрительном и чувственноопосредованном) уровнях натурфилософских и естественнонауч. систем. В ходе человеческого познания происходит конкуренция и смена подобных систем, что сопровождается существенным развитием и изменением представлений о П. и в. Это достаточно чётко проявилось уже в антич-

ной натурфилософии: во-первых, в отличие от бесконечной пустоты Демокрита, пространство Аристотеля конечно и ограничено, ибо сфера неподвижных звёзд пространственно замыкает космос; во-вторых, если пустота Демокрита является началом субстанциально-пассивным, лишь необходимым условием движения атомов, то зпос является началом субстанциально-активным и любое место наделено своей специфич. силой. Последнее характерно для динамику Аристотеля, на базе к-рой была создана геоцентрич. космологич. модель. Космос Аристотеля чётко разделён на земной (подлунный) и небесный уровни. Материальные объекты подлунного мира участвуют либо в прямолинейных естеств. движениях (и движутся к своим естеств. местам (напр., тяжёлые тела устремляются к центру Земли), либо в вынужденных движениях, к-рые продолжаются, пока на них действует движущая сила. Небесный мир состоит из афирных тел, пребывающих в бесконечном совершенном круговом естеств. движении. Соответственно в системе Аристотеля была развита матем. астрономия небесного уровня и качеств. физика (механика) земного уровня мира.

Ещё одно концептуальное достижение Древней Греции, к-рое определило дальнейшее развитие представлений о пространстве (я времени), — это геометрия Евклида, чьи знаменитые «Начала» были развиты в виде аксиоматич. системы и справедливо рассматриваются как древнейшая ветвь физики (А. Эйнштейн) и даже как космологич. теория (К. Поппер (K. Popper), И. Лакатос (I. Lakatos)). Картина мира Евклида отличалась от аристотелевой и включает в себя представление об однородном и бесконечном пространстве. Евклидова геометрия (и оптика) не только сыграла роль концептуальной основы классич. механики, определив такие фундам. идеализированные объекты, как пространство, абсолютно твёрдый (самоконгруэнтный) стержень, геометризованный световой луч и т. д., но и явилась плодотворным матем. аппаратом (языком), с помощью к-рого были разработаны основы классич. механики. Начало классич. механики и сама возможность её построения были связаны с коперниканской революцией 16 в., в ходе к-рой гелиоцентрич. космос предстал как единая конструкция, без деления на качественно отличные небесный и земной уровни.

Дж. Бруно (G. Bruno) разрушил ограничивающую небесную сферу, поместил космос в бесконечное пространство, лишил его центра, заложил основу однородного бесконечного пространства, в рамках к-рого усилиями блестящей плеяды мыслителей (И. Кеплер (I. Kepler), Р. Декарт (R. Descartes), Г. Галилей (G. Galilei), И. Ньютон (I. Newton) и др.) была развита классич. механика. Уровня систематич. разработки она достигла в знаменитых «Математических началах натуральной философии» Ньютона, к-рый разграничивал в своей системе два типа П. и в.: абсолютные и относительные.

Абсолютное, истинное, матем. время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью. Абс. пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остаётся всегда одинаковым и неподвижным.

Таким П. и в. оказались парадоксальными с точки зрения здравого смысла и конструктивными на теоретич. уровне. Напр., концепция абс. времени парадоксальна потому, что, во-первых, рассмотрение течения времени связано с представлением времени как процесса во времени, что логически неудовлетворительно; во-вторых, трудно принять утверждение о равномерном течении времени, ибо это предполагает, что существует нечто контролирующее скорость потока времени. Более того, если время рассматривается «без всякого отношения к чему-либо внешнему», то какой смысл может иметь предположение, что оно течёт неравномерно?

Если же подобное предположение бессмысленно, то какое значение имеет условие равномерности течения? Конструктивный смысл абсолютных Π и ν стал прослеживаться в последующих логико-матем. реконструкциях кинематической механики, к-рые получили свой отсчет. завершение в аналитич. механике Лагранжа (можно отметить также реконструкция Д'Аламбера (D'Alambert), У. Гамильтона (W. Hamilton) и др.), в к-рой был полностью алюминирован геометризм «Начал» и механика предстала как раздел анализа. В этом процессе на первый план стали выступать представления о законах сохранения, принципах симметрии, инвариантности и т. д., к-рые позволяли рассмотреть классич. физику с единых концептуальных позиций. Была установлена связь осн. законов сохранения с пространственно-временной симметрией (С. Ли (S. Lie), Ф. Клейн (F. Klein), Э. Нётер (E. Noether)): сохранение таких фундам. физ. величин, как энергия, импульс и угл. момент, выступают как следствия того, что Π и ν встроены в однородн. Абсолютность Π и ν , абс. характер длины и временных интервалов, а также абс. характер одновременности событий получили чёткое выражение в Галилеев. принципе относительности, к-рый можно сформулировать как принцип ковариантности законов механики относительно Галилеев. преобразований. Т. о., во всех инерциальных системах отсчёта равномерно течёт единое непрерывное абс. время и осуществляется абс. синхронизм (т. е. одновременность событий не зависит от системы отсчёта, она абсолютна), основой к-рого могли выступать лишь действительные мгновенные силы — эта роль в кинематической системе отводилась тяготению («земного тяготения закона»). Однако статус дальностей определяется не природой гравитации, а самой субстанциальной природой Π и ν в рамках механич. картины мира.

От абс. пространства Ньютон отличал протяжённость материальных объектов, к-рая выступает как их осн. свойство и есть пространство относительное. Последнее является мерой абс. пространства и может быть представлено как множество конкретных инерциальных систем отсчёта, находящихся в отсчете движения. Соответственно и отсчет. время есть мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного матем. времени, — это час, день, месяц, год. Отсчет. Π и ν в постигаемы чувствами, но они являются не перцептуальными, а именно эмпирич. структурами отношения между материальными объектами и событиями. Следует отметить, что в рамках эмпирич. фиксации были вскрыты нек-рые фундам. свойства Π и ν , не отраженные на теоретич. уровне классич. механики, напр. трёхмерность пространства или необратимость времени.

Классич. механика до конца 19 в. определяла осн. направление науч. познания, к-рое отождествлялось с познанием механизма явлений, с редукцией любых явлений к механич. моделям и описаниям. Абсолютизация была подвергнута и механич. представления о Π и ν , к-рые были возведены на «Олимп» априорности. В философской системе И. Канта (I. Kant) Π и ν стали рассматриваться как априорные (доопытные, врождённые) формы чувственного созерцания. Большинство философов и естествоиспытателей вплоть до 20 в. придерживались этих априористских воззрений, однако уже в 20-х гг. 19 в. были развиты разл. варианты неевклидовых геометрий (К. Гаусс (C. Gauss), Н. И. Лобачевский, Я. Больяи (J. Boulay) и др.), что связано с существенным развитием представлений о пространстве. Математики давно интересовали вопрос о полноте аксиоматики евклидовой геометрии. В этом отношении наиб. плодотворная вызвала аксиома о параллельных. Был получен поразительный результат: оказалось, что можно развить непротиворечивую систему геометрии, отказавшись от аксиомы о параллельных и допуская существование неск. прямых, параллельных дан-

ной и проходящих через одну точку. Представителем себе такую картину крайне трудно, но учёные уже усвоили геологич. урок кошеринанской революции — наглядность может быть связана с правдоподобностью, но не обязательно с истиной. Поэтому хотя Лобачевский и называл свою геометрию воображаемой, но поставил вопрос об эмпирич. определении евклидова или неевклидова характера физ. пространства. Б. Риман (B. Riemann) обобщил понятие пространства (куда как частные случаи вошли евклидово пространство и всё множество неевклидовых пространств), положив в его основу представление о метрике, — пространство есть трёхмерное многообразие, на к-ром можно аналитически задать разл. аксиоматич. системы, и геометрия пространства определяется с помощью шести компонент метрического тензора, заданных как ф-ция координат. Риман ввёл понятие кривизны пространства, к-рое может иметь положит., нулевое и отрицат. значения. В общем случае кривизна пространства не обязательно должна быть постоянной, а может меняться от точки к точке. На таком пути были обобщены не только аксиома о параллельных, но и др. аксиомы евклидовой геометрии, что привело к развитию неархимедовых, непаскаловых и др. геометрий, в к-рых пересмотру были подвергнуты многие фундам. свойства пространства, напр. его непрерывность, и т. д. Обобщению было подвергнуто также представление о равномерности пространства: была развита теория N -мерных многообразий и стало возможным говорить даже о бесконечномерных пространствах.

Полобная разработка мощного матем. инструментария, существование богатейшего представления о пространстве, сыграла важную роль в развитии физики 19 в. (многомерные фазовые пространства, астремальные принципы и т. д.), для к-рой были характерны значит. достижения и в концептуальной сфере: в рамках термодинамики получило явное выражение [У. Томсон (W. Thomson), Р. Клаузиус (R. Clausius) и др.] представление о неотратности времени — закон возрастания энтропии (второе начало термодинамики), а в электродинамике Фарадея — Максвелла в физику вошли представления о новой реальности — поле, о существовании привилегиров. системы отсчёта, к-рая неразрывно связана с материализов. аналогом абс. пространства Ньютона, с неподвижным эфиром и т. д. Однако немаломеро более плодотворными оказались матем. новации 19 в. в революц. преобразованиях физики 20 в.

Революция в физике 20 в. ознаменовалась разработкой таких неклассич. теорий (и соответствующих физ. исследовательских программ), как частная (специальная) и общая теории относительности (см. *Относительности теории, Тяготение*), квантовая механика, квантовая теория поля, релятивистская космология и др., для к-рых характерно существенное развитие представлений о Π и ν .

Теория относительности Эйнштейна была создана как электродинамика движущихся тел, в основу к-рой были положены новые принцип относительности (относительность обобщалась с механики, явлений на явления эл.-магн. и оптические) и принцип постоянства и предельности скорости света с в пустоте, не зависящей от состояния движения излучающего тела. Эйнштейн показал, что операциональные приёмы, с помощью к-рых устанавливается физ. содержание евклидова пространства в классич. механике, оказались неприменимыми к процессам, протекающим со скоростью, сопоставимыми со скоростью света. Поэтому он начал построение электродинамики движущихся тел с определения одновременности, используя световые сигналы для синхронизации часов. В теории относительности понятие одновременности лишено абс. значения и становится необходимым развить соответствующую теорию преобразования координат (x, y, z) и времени (t) при переходе от покоящейся системы отсчёта

и системе, равномерно и прямолинейно движущейся относительно первой со скоростью v . В процессе развития этой теории Эйнштейн пришёл к формулировке Лоренца преобразований:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Была выведена необособенность двух фундам. положений О. П. и в. в классич. механике: промежуток времени между двумя событиями и расстояние между двумя точками твёрдого тела не зависят от состояния движения системы отсчёта. Поскольку скорость света одинакова во всех системах отсчёта, то от этих положений приходится отказываться и сформировать новые представления о П. и в. Если преобразования Галлея классич. механики основывались на допущении существования операциональных сигналов, распространяющихся с бесконечной скоростью, то в теории относительности операциональные световые сигналы обладают конечной макс. скоростью c и этому соответствует новый закон скорости света, в k -ром в явной форме записана специфика предельно быстрого сигнала. Соответственно сокращение длины и замедление времени носят не динамич. характер (как это представляли Х. Лоренц (H. Lorentz) и Дж. Фицджеральд (G. Fitzgerald) при объяснении отриц. результата *Майкельсона опыта*) и не являются следствием специфики субъективного наблюдения, а выступают элементами новой релятивистской концепции П. и в.

Абс. пространство, единое время для всех систем отсчёта, абс. скорость и т. д. потеряли физико (даже от эфира отказались), были выдвинуты их отсчёт. Аналогично, что, собственно, и определяло теорию Эйнштейна — теория относительности. Но новая пространственно-временная представленная этой теорией не исчерпывалась выявлением относительности длины и временного промежутка, — не менее важным было выяснение равноправности пространства и времени (они равноправно входят в преобразования Лоренца), а в дальнейшем — и инвариантности пространственно-временного интервала. Г. Минковский (H. Minkowski) вскрыл органич. взаимосвязь П. и в., k -рые оказались компонентами единого четырёхмерного континуума (см. *Минковского пространство-время*). Критерий объединения отнесит. свойств П. и в. в абс. четырёхмерное многообразие характеризуется инвариантностью четырёхмерного интервала $(ds)^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$. Соответственно Минковский вновь переносит акцент с относительности на абсолютность (эпостулат абс. мира). В свете этого положения становится ясным несовершенство часто встречающегося утверждения, что при переходе от классич. физики к частной теории относительности произошла смена субстанциальной (абсолютной) концепции П. и в. на реляционную. В действительности имел место иной процесс: на теоретич. уровне произошла смена абс. пространства и абс. времени Ньютона на столь же абсолютное четырёхмерное пространственно-временное многообразие Минковского (это субстанциальная концепция), а на эмпирич. уровне на смену отсчёт. пространству и отсчёт. времени механики Ньютона пришли реляционные П. и в. Эйнштейна (реляционная модификация атрибутивной концепции), основанные на совершенно иной эл.-магн. операциональности.

Частная теория относительности была лишь первым шагом, но новый принцип относительности был приложен лишь к инерциальным системам отсчёта. След. шагом была попытка Эйнштейна распространить эти принципы на системы равноускоренные и вообще на весь круг неинерциальных систем отсчёта — так родилась общая теория относительности. По Ньютонову, неинерциальные системы отсчёта движутся ускоренно относительно абс. пространства. Ряд критиков концепция абс.

пространства [напр., Э. Мах (E. Mach)] предложили рассматривать такое ускоренное движение по отношению к горизонту удалённых звёзд. Тем самым наблюдаемые массы звёзд становились источником инерции. Эйнштейн дал иное толкование этому представлению, исходя из принципа эквивалентности, согласно которому неинерциальные системы локально неотличимы от поля тяготения. Тогда если инерция обусловлена массами Вселенной, а поле сил инерции эквивалентно гравитацион. полю, проявляющемуся в геометрии пространства-времени, то, следовательно, массы определяют и саму геометрию. В этом положении чётко обозначился существенный сдвиг в трактовке проблемы ускоренного движения: принцип Маха об относительности инерции трансформирован Эйнштейном в принцип относительности геометрии пространства-времени. Принцип эквивалентности носит локальный характер, но он помог Эйнштейну сформулировать осн. фза. принципы, на k -рых базируется новая теория: гипотеза о геометрии, природе гравитации, о взаимосвязи геометрии пространства-времени и материи. Кроме этого, Эйнштейн выдвинул ряд матем. гипотез, без k -рых невозможно было бы вывести гравитацион. ур-ния: пространство-время четырёхмерно, его структура определяется симметричным метрич. тензором, ур-ния должны быть инвариантными относительно группы преобразований координат. В новой теории пространство-время Минковского обобщается в метрику искривлённого пространства-

времени Римана: $ds^2 = \sum_{\mu, \nu} g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$, где ds^2 — квадрат

расстояния между точками x^μ, x^ν ; dx^μ и dx^ν — дифференциалы координат этих точек, а $g_{\mu\nu}$ — век-рые ф-ции координат, составляющие фундам. метрич. тензор, и определяют геометрию пространства-времени. Приципиальная новизна подхода Эйнштейна к пространству-времени заключается в том, что ф-ции $g_{\mu\nu}$ являются не только компонентами фундам. метрич. тензора, ответственного за геометрию пространства-времени, но одновременно и потенциалами гравитацион. поля в осн. ур-нии общей теории относительности: $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = -\frac{8\pi G/c^2}{c^4} T_{\mu\nu}$, где $R_{\mu\nu}$ — тензор кривизны, R — скалярная кривизна, $g_{\mu\nu}$ — метрич. тензор, $T_{\mu\nu}$ — тензор энергии-импульса, G — гравитационная постоянная. В этом ур-нии выявлена связь материи с геометрией пространства-времени.

Общая теория относительности получила блестящее эмпирич. подтверждение и послужила основой последующего развития физики и космологии на базе дальнейшего обобщения представлений о П. и в., выяснения их сложной структуры. Во-первых, сама операция геометризации тяготения породила целое направление в физике, связанное с геометризованными едиными теориями поля. Осн. идея: если искривление пространства-времени описывает гравитацию, то введение более обобщённого риманова пространства с повышенной размерностью, с кривизной, с многосвязностью и т. д. даст возможность для описания иных полей (т. е. градиентно-инвариантная теория Бейля, пятимерная *Калюжи — Клейна теория* и др.). В 20—30-е гг. обобщения пространства Римана затрагивали в основном метрич. свойства пространства-времени, однако в дальнейшем речь пошла уже о перестроении топологии [геометродинамика Дж. Уилера (J. Wheeler)], а в 70—80-е гг. физики пришли к выводу, что калибровочные поля глубоко связаны с геометрич. концепцией связности на расслоённых пространствах (см. *Расслоение*) — на этом пути достигнуты впечатляющие успехи, напр. в единой теории эл.-магн. и слабого взаимодействий — теории *электрослабых взаимодействий* Вайнберга — Глашоу — Салама (S. Weinberg, Sh. L. Glashaw, A. Salam), k -рая построена в русле обобщения квантовой теории поля.

Общая теория относительности является осн. совр. релятивистской космологией. Непосредственное применение общей теории относительности ко Вселен-

ной дѣт неизмеримо сложную картину космос. пространства-времени: материя во Вселенной сосредоточена в основном в звездах и их скоплениях, к-рые распределены неравномерно и соответствующим образом искривляют пространство-время, оказываясь неоднородным и неизотропным. Это исключает возможность практич. и матем. рассмотрения Вселенной как целого. Однако ситуация меняется по мере продвижения к крупномасштабной структуре пространства-времени Вселенной: распределение скоплений галактик оказывается в среднем изотропным, реликтовое излучение характеризуется однородностью и т. д. Всё это оправдывает введение космолог. постулата об однородности и изотропности Вселенной и, следовательно, понятия мирового Π и ν . Но это не абс. Π и ν . Ньютона, к-рые, хотя тоже были однородными и изотропными, но в силу евклидова характера имели нулевую кривизну. В применении к неевклидову пространству условия однородности и изотропности влекут постоянно кривизну, и здесь возможны три модификации такого пространства: с нулевой, отрицат. и положит. кривизной. Соответственно в космологии был поставлен очень важный вопрос: конечна ли бесконечна Вселенная?

Эйнштейн столкнулся с этой проблемой при попытке построить первую космологич. модель и пришѣл к выводу, что общая теория относительности несовместима с допущением бесконечности Вселенной. Он разработал конечную и статичную модель Вселенной — сферу. Вселенная Эйнштейна. Речь идет не о привычной и наглядной сфере, к-рую можно часто наблюдать в обшденной жизни. Напр., мыльные пузыри или мячи сферичны, но они являются образами двумерных сфер в трёхмерном пространстве. А Вселенная Эйнштейна представляет собой трёхмерную сферу — замкнутое в себе неевклидово трёхмерное пространство. Оно является конечным, хотя и безграничным. Такая модель существенно обогащает наши представления о пространстве. В евклидовом пространстве бесконечность и неограниченность были единым нерасчлѣнным понятием. На самом деле это разные вещи: бесконечность является метрич. свойством, а неограниченность — топологическим. У Вселенной Эйнштейна нет границ, и она является всеобъемлющей. Более того, сфера. Вселенная Эйнштейна конечна в пространстве, но бесконечна во времени. Но, как выяснилось, стационарность вступала в противоречие с общей теорией относительности. Стационарность пытался спасти разл. методами, что позволило развитие ряда оригинальных моделей Вселенной, однако решение было найдено на пути перехода к нестационарным моделям, к-рые впервые были развиты А. А. Фридманом. Метрич. свойства пространства оказались изменяющимися во времени. В космологию вошла диалект. идея развития. Выяснилось, что Вселенная расширяется [Э. Хаббл (E. Hubble)]. Это вскрыло совершенно новые и необычные свойства мирового пространства. Если в классич. пространственно-временных представлениях разбегание галактик интерпретируется как их движение в абс. ньютоновом пространстве, то в релятивистской космологии это явление оказывается результатом нестационарности метрики пространства: не галактики разлетаются в неизменном пространстве, а расширяется само пространство. Если экстраполировать это расширение вспять во времени, то получается, что наша Вселенная была стянута в точку прибл. 15 млрд. лет назад. Совр. наука не знает, что происходило в этой нулевой точке $t = 0$, когда материя была спрессована в критич. состоянии с бесконечной плотностью и бесконечной была кривизна пространства. Бессмысленно задавать вопрос, что было до этой нулевой точки. Такой вопрос осмыслен в применении к ньютонову абс. времени, а в релятивистской космологии работает иная модель времени, в к-рой в момент $t = 0$ возникает не только стремительно расширяющаяся (или раздувающаяся) Вселенная (Большой взрыв), но и само время. Совр. физика всё

ближе подходит в своём анализе к нулевому моменту, реконструируются реалия, имевшие место через секунду и даже доли секунды после Большого взрыва. Но это уже область глубокого микромира, где работает классич. (неквантовая) релятивистская космология, где вступают в силу квантовые явления, а к-рым связь с другой путѣ развития фундам. физики 20 в. со своим специфич. представлениями о Π и ν .

В основе этого пути развития физики лежало открытие М. Планком (M. Planck) дискретности процесса испускания света: в физике появился новый атом — атом действия, или квант действия, $h = 6,55 \cdot 10^{-27}$ эрг-с, к-рый стал новой мировой константой. Мн. физики [напр., А. Эддингтон (A. Eddington)] с момента появления кванта подчёркивали загадочность его природы: он неделим, но не имеет границ в пространстве, он как бы заполняет собой всё пространство, и не ясно, какое место следует отвести ему в пространственно-временной схеме мироздания. Место кванта было чѣтко вынесено в квантовой механике, вскрывшей закономерности атомного мира. В микромире становится бессодержательным понятие пространственно-временной траектории частицы (обладающей как корпускулярными, так и волновыми свойствами), если под траекторией понимается классич. образ линейного континуума (см. *Причинность*). Поэтому в первые годы развития квантовой механики её создатели делали осн. упор на раскрытие того факта, что она не даёт описания движения атомных частиц в пространстве и времени и ведѣт к полному отказу от привычного пространственно-временного описания. Выявилась необходимость пересмотра пространственно-временных представлений и лапласовского детерминизма классич. физики, ибо квантовая механика является принципиально статистич. теорией и ур-ние Шрёдингера описывает амплитуду вероятности нахождения частицы в данной пространственной области (расширяется и само понятие пространственных координат в квантовой механике, где они изображаются операторами). В квантовой механике было открыто наличие принципиального ограничения точности при измерениях на малых расстояниях параметров микрообъектов, обладающих энергией порядка той, к-рая вносится в процессе измерения. Это обуславливает необходимость наличия двух дополняющих друг друга эксперим. установок, к-рые в рамках теории формируют два дополнительных описания поведения микрообъектов: пространственно-временное и импульсно-энергетическое. Любое повышение точности определения пространственно-временной локализации квантового объекта сопряжено с повышением неточности в определении его импульсно-энергетич. характеристик. Неточности измеряемых физ. параметров образуют *неопредѣленностей соотношения*: $\Delta x \cdot \Delta p \geq h$, $\Delta E \cdot \Delta t \geq h$. Важно, что указанная дополнительность содержится и в самом матем. формализме квантовой механики, определяя дискретность фазового пространства.

Квантовая механика была положена в основу бурно развивающейся физики элементарных частиц, в к-рой представления о Π и ν столкнулись с ещё большими трудностями. Оказалось, что микромир является сложной многоуровневой системой, на каждом уровне к-рой господствуют специфич. виды взаимодействий и характерные специфич. свойства пространственно-временных отношений. Область доступных в эксперименте микроскопич. интервалов условно можно поделить на четыре уровня: уровень молекулярно-атомных явлений (10^{-8} см $< \Delta x < 10^{-11}$ см); уровень релятивистских квантовоелектродинамич. процессов: уровень элементарных частиц; уровень ультрамалых масштабов ($\Delta x \leq 10^{-16}$ см и $\Delta t \leq 10^{-20}$ с — эти масштабы доступны в опытах с космич. лучами). Теоретически можно ввести и значительно более глубокие уровни (лежащие далеко за пределами возможностей не только сегодняшних, но и завтрашних эксперимен-

тов), с к-рыми связаны такие концептуальные новации, как флуктуация метрики, изменения топологии, «пенообразная структура» пространства-времени на расстояниях порядка *планковской длины* ($\Delta x \leq 10^{-33}$ см). Однако достаточно решительный пересмотр представлений о П. и в. потребовался на уровнях, вполне доступных совр. эксперименту при развитии физики элементарных частиц. Уже квантовая электродинамика столкнулась со многими трудностями именно потому, что была связана с заимствованными из классич. физики понятиями, основанными на концепции пространственно-временной непрерывности: точечность заряда, локальность поля и т. д. Это повлекло за собой существенное осложнение, связанные с бесконечными значениями таких важных величин, как масса, спин, энергия электрона и т. д. (*ультрафиолетовые расходимости*). Эти трудности пытались преодолеть введением в теорию представления о дискретном, квантованном пространстве-времени. Первые разработки 30-х гг. (В. А. Амбарцумян, Д. Д. Иваненко) оказались неконструктивными, ибо не удовлетворяли требованию относительной инвариантности, а трудности квантовой электродинамики были решены с помощью процедуры *перенормировки*: малость константы эл.-магн. взаимодействия ($\alpha = 1/137$) позволила использовать ранее разработанную теорию возмущений. Но в построении квантовой теории др. полей (слабого и сильного взаимодействия) эта процедура оказалась не работающей, и выход стали искать на пути ревизии концепции локальности поля, его линейности и т. д., что опять наметило возврат к идее существования «атомов» пространства-времени. Это направление получило новый импульс в 1947, когда Ч. Снайдер (H. Snyder) показал возможность существования релятивистски инвариантного пространства-времени, в к-ром содержится естеств. единица длины l_0 . Теория квантованного П. и в. получила развитие в работах В. Г. Авербаха, Б. В. Медведева, Ю. А. Гольдфада, В. Г. Кадышеского, Р. М. Мир-Касимова и др., к-рые стали приходить к выводу, что в природе существует *фундаментальная длина* $l_0 \sim 10^{-17}$ см. Дж. Чу (G. Chew), Э. Циммерман (E. Zimshermann) и др. экспериментально представили о дискретности пространства-времени в гипотезу о макроскопич. природе П. и в. Речь стала идти не о специфике дискретной структуры П. и в. в физике элементарных частиц, а о наличии некоей границы в микромире, за к-рой вообще нет ни пространства, ни времени. Весь этот комплекс идей продолжает привлекать внимание исследователей, но существенный прогресс был достигнут Ч. Янгом (Ch. Yang) и Р. Миллсом (R. Mills) путём небезопасного обобщения квантовой теории поля (*Янга — Миллса поля*), в рамках к-рого удалось не только реализовать процедуру перенормировки, но и приступить к реализации программы Эйнштейна — к построению единой теории поля. Создана единая теория электро-слабых взаимодействий, к-рая в пределах расширенной симметрии $U(1) \times SU(2) \times SU(3)_c$ объединяется с квантовой гравитационной (теорией сильных взаимодействий). В этом подходе проносятся синтез ряда оригинальных идей и представлений, напр. гипотезы кварков, цветовой симметрии кварков $SU(3)_c$, симметрии слабых и эл.-магн. взаимодействий $SU(2) \times U(1)$, локально калибровочного и неабелевого характера этих симметрий, существования спонтанно нарушенной симметрии и перенормируемости. Причём требование локальности калибровочных преобразований устанавливает ранее отсутствующую связь между динамик. симметриями и пространством-временем. В настоящее время разрабатывается теория, объединяющая все фундам. физ. взаимодействия, включая гравитационные. Однако выяснилось, что в этом случае речь идёт о пространствах 10, 26 и даже 605 размерностей. Исследователи надеются, что чрезмерный избыток размерностей в процессе компактификации удастся «замкнуть» в области планковских масштабов и в теорию макромира войдёт

лишь привычное четырёхмерное пространство-время. Что же касается вопросов о структуре пространства-времени глубокого микромира или о первых мгновениях Большого взрыва, то ответы на них будут найдены лишь в физике 3-го тысячелетия.

Лит.: Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения, 2 изд., М., 1961; Пространство и время в современной физике, Н., 1968; Грюнбаум А., Философские проблемы пространства и времени, пер. с англ., М., 1984; Уткин И. О. Э. М., Пространство и время в современной физике, М., 1969; Влохинцев Д. И., Пространство и время в микромире, 2 изд., М., 1982; Мостепаневичи А. М., Пространство-время и физическое познание, М., 1975; Хоккинг С., Эддингс Дж., Крупномасштабная структура пространства-времени, пер. с англ., М., 1977; Дези П. С., Пространство и время в современной картине Вселенной, пер. с англ., М., 1979; Бэршан И. и др., С., Проблемы субатомного пространства-времени, М., 1979; Ахундов М. Д., Пространство и время в физическом познании, М., 1982; Влاديимиров Ю. С., Мидкевич Н. В., Хороски А., Пространство, время, гравитация, М., 1984; Редькин Б. Г., Философия пространства и времени, пер. с англ., М., 1985; Вледиимиров Ю. С., Пространство-время: явные и скрытые размеры, М., 1989.

М. Д. Ахундов.

ПРОСТРАНСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ — см. *Изображение оптическое.*

ПРОСТРАНСТВО ПРЕДМЕТА — см. *Изображение оптическое.*

ПРОТАКТИЙ (Protactinium), Pa, — радиоактивный хим. элемент III группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 91, относится к *актиноидам*. Все изотопы П. радиоактивны. В природе существует ^{231}Pa ($T_{1/2} = 3,28 \cdot 10^4$ лет) — член естеств. радиоактивного ряда ^{235}U (в лабораториях этот изотоп выделен в кол-ве ок. 150 г). В состав естеств. радиоактивного ряда ^{238}U входят ядерные изомеры $^{234\text{m}}\text{Pa}$ (β -радиоактивные, $T_{1/2} = 1,18$ мин и $T_{1/2} = 6,7$ ч). Искусственно получены изотопы ^{231}Pa — ^{239}Pa , из них наиб. применению получил β -радиоактивный ^{233}Pa ($T_{1/2} = 27$ сут), образующийся в реакции $^{232}\text{Th}(\text{p}, \gamma)^{233}\text{Pa}$. Электронная конфигурация внеш. электронных оболочек $5s^2 4f^6 5d^0 6s^2 6p^4 7s^2$. Энергия ионизации 5,9 эВ. Металлич. радиус атома Pa 0,163 нм, радиус иона Pa^{3+} 0,105 нм, Pa^{4+} 0,096 нм, Pa^{5+} 0,090 нм. Значение электроотрицательности 1,14.

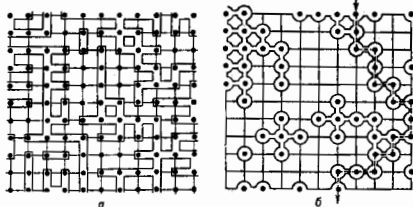
Металлич. П. существует в виде двух модификаций: ниже 1170 °С устойчив α -Pa (тетрагональная кристаллич. структура, постоянные решётки $a = 0,3931$ нм и $c = 0,3236$ нм), выше 1170 °С — β -Pa (объёмноцентрированной кубич. кристаллич. структура, постоянная решётки $a = 0,5019$ нм). Плотность α -Pa 15,34 кг/дм³, β -Pa 12,13 кг/дм³; $t_{\text{пл}}$ ок. 1575 °С, $t_{\text{кип}} = 4230$ —4500 °С, теплота плавления 12 кДж/моль, теплота испарения 552 кДж/моль, теплосодержание $c_p = 27,6$ Дж/(моль·К). Уд. электрич. сопротивление 0,19 мкОм·см, термич. коэф. линейного расширения $11,2 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹. По твёрдости близок к урану.

В хим. соединениях проявляет степени окисления +3, +4 и +5 (наиб. устойчив). Хим. свойства Pa во многом отличаются от свойств др. актиноидов. Потенц. практич. значение Pa связано с предполагаемым использованием ^{233}Th для получения ядерного горючего (при облучении ^{232}Th нейтронами он превращается в ^{233}Pa , при последующем β -распаде ^{233}Pa образуется ^{233}U , к-рый можно использовать как делющийся материал).

С. С. Берковский.

ПРОТЕКАНИЯ ТЕОРИЯ (перколяция теория, от лат. *percolatio* — процеживание; просачивания теория) — математ. теория, к-рая используется в физике для изучения процессов, происходящих в неоднородных средах со случайными свойствами, но зафиксированными в пространстве и неизменными во времени. Возникла в 1957 в результате работ Дж. Хаммерсли (J. Hammettley). В П. т. различают решёточные задачи П. т., континуальные задачи и т. н. задачи на случайных узлах. Решёточные задачи в свою очередь делятся на т. н. задачи узлов и задачи связей между ними.

Задачи связей. Пусть связи — рёбра, соединяющие соседние узлы бесконечной периодич. решётки (рис., а). Предполагается, что связи между узлами могут быть двух типов: целыми или разорванными (блокированными). Распределение целых и блокированных связей в решётке случайно; вероятность того, что данная связь является целой, равна x . Предполагается, что она не зависит от состояния соседних связей. Два узла решётки считаются связанными друг с другом, если их соединяет цепочка целых связей. Совокупность связанных друг с другом узлов наз. к л а с т е р о м. При малых значениях x целые связи, как правило, далеки



Протекание по решётке: а — задачи связей (путь протекания сквозь указанный блок отсутствует); б — задачи узлов (показан путь протекания).

друг от друга и доминируют кластеры из небольшого кол-ва узлов, однако с увеличением x размеры кластеров резко увеличиваются. По ро г о м пр о т е к а н и я (x_c) наз. такое значение x , при к-ром впервые возникает кластер из бесконечного числа узлов. П. т. позволяет вычислить пороговые значения x_c , а также исследовать топологию крупномасштабных кластеров вблизи порога (см. *Фракталы*). С помощью П. т. можно описать электропроводность системы, состоящей из проводящих и непроводящих элементов. Напр., если предположить, что целые связи проводят электрич. ток, а блокированные не проводят, то окажется, что при $x < x_c$ уд. электропроводность решётки равна 0, а при $x > x_c$ она отлична от 0.

Решёточные задачи узлов отличаются от задач связей тем, что блокированные связи распределены на решётке не поодиночке — блокируются все связи, выходящие из к.-л. узла (рис., б). Блокированные таким способом узлы распределены на решётке случайно, с вероятностью $1 - x$. Доказано, что порог x_c для задачи связей на любой решётке не превышает порога x_c для задачи узлов на той же решётке. Для нек-рых плоских решёток найдены точные значения x_c . Напр., для задач связей на треугольной и шестугольной решётках $x_c = 2\sin(\pi/18)$ и $x_c = 1 - 2\sin(\pi/18)$. Для задач узлов на квадратной решётке $x_c = 0,5$. Для трёхмерных решёток значения x_c найдены приближённо с помощью моделирования на ЭВМ (табл.).

Пороги протекания для различных решёток

Тип решётки	x_c для задачи связей	x_c для задачи узлов	
Плоские решётки	шестугольная	0,6527	
	квадратная	0,5	
	треугольная	0,3473	
Трёхмерные решётки	тип алмаза	0,39	0,43
	простая кубическая	0,25	0,31
	объёмноцентрированная кубическая	0,18	0,25
	гранецентрированная кубическая	0,12	0,2

Континуальные задачи. В этом случае вместо протекания по связям и узлам рассматриваются явления переноса в неупорядоченной сплошной среде. Во всём пространстве задается непрерывная случайная ф-ция координат $V(r)$. Зафиксируем нек-рое значение ϵ ф-ции $V(r)$ и назовём области пространства, в к-рых $V(r) < \epsilon$, чёрными. При достаточно малых значениях ϵ эти области редки и, как правило, изолированы друг от друга, а при достаточно больших ϵ они занимают почти всё пространство. Требуется найти т. н. уровень протекания ϵ_p — мин. значение ϵ , при к-ром чёрные области образуют связанный лабиринт путей, уходящий на бесконечное расстояние. В трёхмерном случае точное решение континуальной задачи пока не найдено. Однако моделирование на ЭВМ показывает, что для гауссовых случайных ф-ций $V(r)$ в трёхмерном пространстве при $\epsilon = \epsilon_p$ доля объёма, занимаемая чёрными областями, приближённо равно 0,16. В двумерном случае доля площади, занимаемая чёрными областями при $\epsilon = \epsilon_p$, точно равна 0,5.

Задачи на случайных узлах. Пусть узлы не образуют правильную решётку, а случайно распределены в пространстве. Два узла считаются связанными, если расстояние между ними не превышает фиксированное значение r . Если r мало по сравнению со ср. расстоянием между узлами, то кластеры, содержащие 2 или больше связанных друг с другом узлов, редки, однако число таких кластеров резко растёт с увеличением r и при нек-ром критич. значении r_c возникает бесконечный кластер. Моделирование на ЭВМ показывает, что в трёхмерном случае $r_c \approx 0,86 N^{-1/3}$, где N — концентрация узлов. Задачи на случайных узлах и их разл. обобщения играют важную роль в теории *прямж-ковой проводимости*.

Эффекты, описываемые П. т., относятся к *критическим явлениям*, характеризующимся критич. точкой, вблизи к-рой система распадается на блоки, причём размер отд. блоков неограниченно растёт при приближении к критич. точке. Возникновение бесконечного кластера в задачах П. т. во многом аналогично *фазовому переходу* второго рода. Для матем. описания этих явлений вводится *параметр порядка*, к-рым в случае решёточных задач служит доля $P(x)$ узлов решётки, принадлежащих к бесконечному кластеру. Вблизи порога протекания ф-ция $P(x)$ имеет вид

$$P(x) = B_1(x - x_c)^\beta \text{ при } x > x_c,$$

$$P(x) = 0 \text{ при } x < x_c,$$

где B_1 — численный коэф., β — критич. индекс параметра порядка. Аналогичная ф-ла описывает поведение уд. электропроводности $\sigma(x)$ вблизи порога протекания:

$$\sigma(x) = B_2 \sigma(1)(x - x_c)^t \text{ при } x > x_c,$$

$$\sigma(x) = 0 \text{ при } x < x_c,$$

где B_2 — численный коэф., $\sigma(1)$ — уд. электропроводность при $x = 1$, t — критич. индекс электропроводности. Пространственные размеры кластеров характеризуются радиусом корреляции $R(x)$, обращающимся в ∞ при $x \rightarrow x_c$:

$$R(x) = B_3 a |x - x_c|^{-\nu}.$$

Здесь B_3 — численный коэф., a — постоянная решётки, ν — критич. индекс радиуса корреляции.

Пороги протекания существенно зависят от типа задач П. т., но критич. индексы одинаковы для разл. задач и определяются лишь размерностью пространства d (универсальность). Представления, асимптотические на теории фазовых переходов 2-го рода, позволяют получить соотношения, связывающие различные критич. индексы. Приближение *самогласованного поля* применимо к задачам П. т. при $d > 6$. В этом приближении критич. индексы не зависят от d ; $\beta = 1$, $\nu = 1/2$.

Результаты П. т. используются при изучении электронных свойств *неупорядоченных систем*, фазовых переходов *металл — диэлектрик*, ферромагнетизма твердых растворов, кинетики явлений в сильно неоднородных средах, физ.-хим. процессов в твердых телах и т. д. Лит.: Мотт Н., Дэвис Э., Электронные процессы в неупорядоченных веществах, пер. с англ., 2 изд., т. 1—3, М., 1982; Шлоески В. В., Зворыс А. Д., Электронные свойства легированных полупроводников, М., 1979; Зворыс А. Д., Модели беспорядка, пер. с англ., М., 1982; Зворыс А. Д., Физика и геометрия беспорядка, М., 1982; Соколов И. М., Размеры и другие геометрические критерические показатели в теории протекания, «УФН», 1986, т. 150, с. 221.

ПРОТИЙ (лат. Protium, от греч. prótos — первый), ^1H — стабильный и наиболее распространенный в природе (99,98%) изотоп водорода с массовым числом 1. Атомное ядро H — протон.

ПРОТОЗВЕЗДЫ. Общепринятого и полного определения П. не существует, хотя это понятие широко используется в астрофизике. Наиб. часто под П. понимают объект, находящийся на стадии *эволюции звезд* от коллапсирующего родительского межзвездного облака до появления в центре облака полости ионизованного гидростатически равновесного ядра, т. е. зародыша молодой звезды. Это ядро сжимается и взаимодействует с остатками облака довольно сложным образом, приобретая структуру и параметры «обычной» звезды. Понятие П. иногда распространяют и на эту стадию сжатия вплоть до того момента, когда начинают «работать» осн. ядерные источники энергии и звезда «сдавлена» на главную последовательность Герцшпрунга — Рассела диаграммы.

Звезды образуются в результате сжатия межзвездных облаков (см. *Звездообразование*). Сжатие межзвездного газа обусловлено силами гравитации и внеш. давлением, к-рым противодействуют силы теплового давления, центробежные, магнитного поля, турбулентного давления и т. д. Наиб. важный вид неустойчивости, приводящий к сжатию облака и в конечном счете к образованию звезды, — *гравитационная неустойчивость*. Порог этой неустойчивости обычно характеризуют джинсовской массой $M_{\text{дж}}$. Эта масса, содержащаяся в сфере диаметром, равным критич. длине волны гравитат. неустойчивости в бесконечной однородной среде, т. е. джинсовской длине $\lambda_{\text{дж}} = \sqrt{\frac{c_s}{4\pi G \rho}}$, где c_s — скорость звука, ρ — плотность. При массе облака $M_0 > M_{\text{дж}}$ изотермич. газовая конфигурация начинает сжиматься практически в режиме свободного падения — коллапсировать. (Изотермичность обеспечивается эфф. потерями на излучение пыли, а также потерями на столкновит. возбуждение тонкой структуры атомов и ионов С, O, Si и т. д.) Др. критерий гравитат. неустойчивости изотермич. газового пара получается, если учесть внеш. давление: $P_{\text{вн}}$; коллапс развивается при $M_0 > M_{\text{в}} = 1,8 \frac{c_s}{\sqrt{4\pi G P_{\text{вн}}}}$. В недрах плотных облаков или в одиночной глобуле, обжимаемой внеш. давлением (напр., в *зоне HII*), этот критерий может быть выполнен заведомо до того, как будет выполнен критерий $M_0 > M_{\text{дж}}$. В ряде случаев магн. поле играет, по-видимому, осн. роль в обеспечении механич. равновесия облаков. Квазиоднородное магн. поле, характеризуемое потоком F , может удерживать облако от коллапса, если масса облака не превышает критич. значения $M_F = 0,15 F / G^{1/2}$. Напр., поле с индукцией 30 мкГс может удерживать в равновесии сгусток массой $1,0 M_{\odot}$ (M_{\odot} — масса Солнца) и радиусом ≈ 2 пк. Прямые свидетельства существования магн. поля такой величины в нек-рых молекулярных облаках получены по наблюдениям зееманового расщепления линий. В каждом конкретном случае доминирует тот механизм, к-рому соответствует наименьшая критич. масса. Развитие коллапса может стимулироваться и хим. реакциями. Напр., в условиях прерывного звездообразования в среде, не содержащей тяжелых элементов, важнейший фактор, обеспечивающий коллапс об-

лаков с массами порядка звездных, — охлаждение вследствие возбуждения вращат. уровней молекул H_2 и последующего излучения. (Такие молекулы образуются в реакциях $\text{H} + e^- \rightarrow \text{H}^- + \text{h}\nu$, $\text{H}^- + \text{H} \rightarrow \text{H}_2 + e^-$, а также $3\text{H} \rightarrow \text{H}_2 + \text{H} \cdot$) Критич. массы для наиб. распространенного компонента межзвездной среды — диффузных облаков ($\rho \approx 10^{-22}$ г·см $^{-3}$, $T_{\text{тем}} = 50$ —2000 К) — слишком велики, и в этих объектах звезды образовываться не могут. В случае плотных и холодных молекулярных облаков ($\rho > 10^{-21}$ г·см $^{-3}$, $T \lesssim 50$ К), т. е. облаков, наблюдаемых в линиях CO и др. молекул, значения критич. масс близки к звездным и именно в молекулярных облаках наблюдается активное звездообразование. Набл. вероятные места рождения звезд — ядра молекулярных облаков, представляющие собой плотные и холодные газовые сгустки ($\rho \approx 10^{-20}$ — 10^{-18} г·см $^{-3}$, $T \approx 10$ —400 К).

В теоретич. исследованиях П. наиб. внимание уделяется численным методам моделирования, поскольку они позволяют получать количеств. оценки при решении нелинейных систем ур-ний газодинамики (радиат. газодинамики), описывающих эволюцию П. Согласно результатам аналитич. и численных методов, коллапс гравитационного неустойчивого фрагмента газово-пылевого облака протекает негомологично (неоднородно). Негомологичность может быть обусловлена изначально неоднородным распределением плотности (напр., в ядрах молекулярных облаков отмечается концентрация веще-

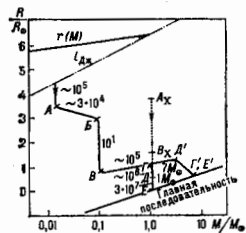


Рис. 1. Изменение радиусов R и масс M ядер прото звезд с массами $1 M_{\odot}$ и $7 M_{\odot}$ аккрецирующих вещество холодного (10 К) родительского облака. В случае массивной прото звезды аккреция прекращается (точка G') только на главной последовательности, до этого момента звезда остается ненаблюдаемой в видимом диапазоне. $\lambda_{\text{дж}}$ — джинсовская длина волны, числа означают длительность стадий в годах для прото звезд с массой $1 M_{\odot}$, пунктир соответствует модели Хэнси для $1 M_{\odot}$, $r(M)$ — зависимость радиуса от массы (содержащейся в сфере радиуса r) для однородного сферического облака с полной массой $1 M_{\odot}$, ρ — находящегося на границе гравитационной неустойчивости.

ства к центру). Даже в однородном облаке коллапс со временем становится негомологичным, поскольку возникающий на границе облака градиент давления не компенсируется к-л. реальными гравитачными условиями, и во всех случаях появляется продвигающаяся к центру волна разрежения. Затем в центре облака за характерное время свободного падения $t_{\text{св}} = (3\pi/32G\rho)^{1/2}$ образуется небольшое гидростатически равновесное квазиадиабатически сжимающееся ядро с массой $M \approx 0,01 M_{\odot}$ (точка А на рис. 1 и 2). Причина образования ядра — возрастная непрозрачность к собственному ИК-излучению, и, как следствие, рост темп-ры и градиента давления, остающегося коллапс. Ядро аккрецирует вещество оболочки, к-рая продолжает падать свободно. Рост массы ядра сопровождается его дальнейшим сжатием и нагревом (А — В). По мере роста темп-ры происходит ионизация водорода, диссоциация, а затем и ионизация водорода, ядро испытывает фазу второго коллапса (В — В'), превращаясь в молот-

дую звезду, окружённую мощной газовой-пылевой оболочкой (такие оболочки иногда на протозвездах). Дальнейшая эволюция аккрецирующей молодой звезды ($B - \Gamma$) сопровождается ростом массы с характерным временем аккреции $t_a \sim 10^7 (M/M_\odot) T^{-3/2}$ лет (T — темп-ра протозвёздного облака). Вследствие большой непрозрачности ионизов. вещества в звезде развивается конвекция

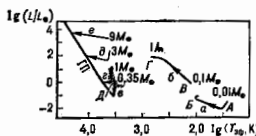


Рис. 2. Эволюционные треки гидростатически равновесных протозвезд на диаграмме Герцшпрунга — Рассела. L — светимость, $T_{\text{эф}}$ — эффективная температура. Треки a, b, c относятся к протозвезде с массой $1 M_\odot$, a, b, c — к протозвездам с массами $0.35 M_\odot$, $3 M_\odot$, $9 M_\odot$. Затрихованная область — т. н. линия рождения звёзд. Разным в треках соответствуют различным гидростатическому равновесию и очень быстрой эволюции с характерным временем t_a .

(см. Конвективная неустойчивость). Конвективный механизм теплоотвода настолько эффективен, что звезда сжимается при практически постоянной поверхности (эффективной) темп-ре. После прекращения аккреции звезда становится наблюдаемой в оптич. диапазоне (линии рождения звёзд — затрихованная область на рис. 2) и сжимается вдоль вертикального (конвективного) трека на диаграмме Герцшпрунга — Рассела ($\Gamma - D$). В результате перестройки структуры звезды её радиус R и светимость L уменьшаются. Когда L уменьшится до мин. значения для равновесных конвективных звёзд, условие конвективной неустойчивости нарушится и появляется радиативное ядро (ядро с лучистым переносом энергии, см. Лучистое равновесие). Звезда переходит на горизонтальный (на диаграмме Герцшпрунга — Рассела) или радиативный трек ($D - E$) и эволюционирует вдоль него с характерным временем тепловой релаксации (т. е. время Кельвина — Гельмгольца) $t_{\text{КГ}} \approx 3 \cdot 10^7 (M/M_\odot)^2 (R/R_\odot)(L/L_\odot) (R_\odot/L_\odot)$ — радиус и светимость Солнца). На рис. 1 для сравнения приведён трек аналитич. модели П. ($M = 1 M_\odot$), предложенной в работах группы Ч. Хаяси (Ch. Hayashi), оказавших в 60-е гг. большое влияние на развитие представлений о П.

Протозвёздные оболочки существуют в течение характерного времени t_a , т. е. при обычных условиях, $\sim 10^6 - 10^8$ лет. Они определяют наблюдаемые проявления П., поскольку непрозрачны в видимом диапазоне и перерабатывают б. ч. излучения молодых звёзд в ИК-излучение (рис. 3). Поэтому такие оболочки на такие коконы. Непрозрачность обусловлена пылью, темп-ра k -рой для силикатных частиц не превышает 1000 K , а б. ч. пыли ещё холоднее ($\approx 100 \text{ K}$). Вследствие этого П. излучают осн. долге энергии в диапазоне, недоступном для наземных наблюдений, и изучаются методами внеатмосферной астрономии. Вокруг достаточно массивных звёзд по мере увеличения их эфф. темп-ры образуются зоны НИ. Коконы поглощают видимое излучение из ИК-области. Градиент давления излучения и ионизов. водорода препятствует коллапсу оболочки и в конечном итоге приводит к разлёту оболочки. Более раннюю стадию эволюции П. (коллапс) наблюдать трудно вследствие малой скорости выделения энергии на этой стадии.

Комплексные наблюдения П. обнаруживают сложный характер движений вещества в этих объектах и их ок-

рестностях. Характерны биполярные истечения больших масс (до $100 M_\odot$) со скоростями десятки км/с, узкие струи (джеты), скорости k -рых составляют сотни км/с, диски вокруг центрального источника, так что изображённые на рис. 3 «разрезы» протозвёздных оболочек следует считать «экваториальными». Вещество на окрестности очень молодых звёзд истекает вдоль ос сим-

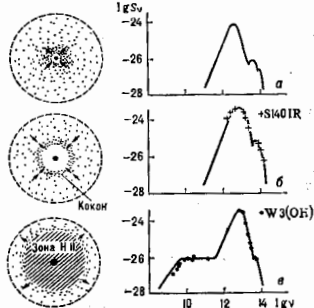


Рис. 3. Последовательные стадии эволюции структуры протозвезды с массой $5.0 M_\odot$ и теоретического спектра выходящего из неё излучения. Плотность потока S , дана в Вт/(м²·Гц), частота ν в Гц. Для сравнения показаны нормированные по расстоянию спектры источника протозвёздного типа S1401R и компактной зоны НИ W3 (ОН). Стрелками показано движение вещества.

метрии, и, по-видимому, существует неск. мощных механизмов перекачки энергии коллапса вращающегося облака в энергию таких направленных движений. Моделировать динамику протозвёздных оболочек и компактных зон НИ довольно сложно, особенно с учётом влияния вращения и магн. поля, и пока что полной и общепринятой модели таких объектов не существует.

Лит.: S. H. F. N., A. D. A. M., F. C. L. L. I. S. A. P. S. Star formation in molecular clouds: observation and theory, «Ann. Rev. Astron. Astrophys.», 1987, v. 25, p. 23; Шустов в Б. М., Молекулярные ядра и протозвезды, в сб.: Современные проблемы физики и эволюции звезд, М., 1989; Бисноватый-Корган Г. С., Физические вопросы теории звёздной эволюции, М., 1989. В. М. Шустов.

ПРОТОН (от греч. *prōton* — первый) (символ p) — стабильная элементарная частица, ядро атома водорода. Масса $m_p = 1,672614(14) \cdot 10^{-24}$ г $\approx 1836 m_e$, где m_e — масса электрона; в энергетич. единицах $m_p \approx 939,3$ МэВ. Электрич. заряд П. положительн: $e = 4,803242(14) \cdot 10^{-10}$ СГСЭ единиц заряда. Спин П. равен $1/2$, поэтому П. подчиняются Ферми — Дирака статистике. Магн. момент П. $\mu_p = 2,792763(30) \mu_N$, где μ_N — ядерный магнетон. Вместе с нейтронами n образуют атомные ядра всех хим. элементов, при этом число П. в ядре равно атомному номеру данного элемента и, следовательно, определяет место элемента в периодич. системе элементов Менделеева. Существует античастица по отношению к П. — *антипротон*.

К протонам (о П. привели создание планетарной модели атома [Э. Резерфорд (E. Rutherford), 1911]; открытие протонов [Ф. Содди (F. Soddy), Дж. Дж. Томсон (J. J. Thomson), Ф. Астон (F. Aston), 1906—19]; атомные массы k -рых оказали кратным атомной массе водорода; эксперим. наблюдение ядер водорода, выбитых с частицами из ядер др. элементов (Резерфорд, 1919—20). Гермия «П» явил Резерфорд в нач. 20-х гг.

П. является *адрон*ом. Кроме сильного взаимодействия он также участвует во всех др. фундам. взаимодействиях: электромагнитном, слабом и гравитационном. П. относится к классу *барион*ов; его барионное число $B = 1$. Законом сохранения барионного числа

определяется стабильность Π . — самого легкого из бариев. По геохим. данным, время жизни Π $\tau_p > 1,6 \cdot 10^{10}$ лет, а по данным эксперим. исследований конкретных видов распада Π , $\tau_p > 10^{11}$ лет. Модели т. и. в. *малоко* объединяют сильного, слабого и эл.-магн. взаимодействий предсказывают нарушение закона сохранения барионного числа и соответственно стабильности протона с τ_p , зависящим от детальной структуры модели и лежащим в диапазоне времён $10^{10} - 10^{10}$ лет.

В сильном взаимодействии Π и нейтрон имеют одинаковые свойства и рассматриваются как два зарядовых состояния одной частицы — нуклона, к-рому приписывается квантовое число *изотопический спин* $I = 1/2$ (см. *Изотопическая инвариантность*). Важнейшее проявление сильного взаимодействия с участием Π . — ядерные силы, связывающие нуклоны в ядре. При теоретич. описании сильного взаимодействия Π плодотворным оказался подход, основанный на предположении о том, что Π окружен облаком *виртуальных частиц*, к-рые он непрерывно испускает и поглощает. Взаимодействие Π с др. частицами рассматривается как процесс обмена виртуальными частицами. Напр., ядерные силы и взаимодействие. процессы объясняются в основном обменом виртуальными пионами между нуклонами. Эксперим. данные по рассеянию Π и нейтронов более высоких энергий объясняются участием в виртуальных процессах наряду с отд. пионами групп пионов, а также разл. мезонных резонансов.

эл.-магн. свойства Π неразрывно связаны с наличием вокруг него облака виртуальных адронов. Именно взаимодействием γ -кванта с виртуальными пионами качественно объясняется большое отличие магн. момента Π от ядерного магнетона. Исследования рассеяния электронов и γ -квантов на Π позволили найти пространственное распределение электрич. заряда и магн. момента Π . — его *формфактор* Р. Хофштадтер (R. Hofstadter) и др., 1957), а также обнаружить электрч. и магн. поляризуемость Π . (В. И. Гольдманский и др., 1960), т. е. получить эксперим. доказательство существования внутр. структуры Π . Т. о., Π не является точечной частицей; его среднеквадратичный радиус равен 0,8 Ф.

Примерами слабого взаимодействия с участием Π являются внутрядерные превращения Π в нейтрон и, наоборот, ипроявляющиеся в виде *бета-распада* ядер и электронного захвата.

Совр. трактовка структуры Π основана на кварковой модели адронов. согласно к-рой Π состоит из двух *u*-кварков и одного *d*-кварка, удерживаемых силами, связанными с обменом др. гипотетич. частицами — *глуконами* (см. *Кварки, Квантовая хромодинамика*). Кварки, в свою очередь, окружены облаком виртуальных глюонов и кварк-антикварковых пар. Эксперим. данные по процессам с большой передачей импульса, напр. по *слабоко нейтральному процессу* рассеяния электронов на Π , свидетельствуют о существовании внутри Π *точечноподобных* рассеивающих центров — *партонов*. С точки зрения кварковой модели, партонами являются кварки.

Ввиду стабильности Π , наличия у него электрч. заряда и относит. простоты получения (ионизацией водорода) пучки ускоренных Π являются одним из осн. инструментов эксперим. физики элементарных частиц. Очень часто мишенью в опытах по соударению частиц также являются Π . — свободные (водород) или связанные в ядрах. Π . высокой энергии получают на ускорителях. Ускоренные Π используются не только для изучения рассеяния самих Π , но также и для получения пучков частиц: л- и К-мезонов, антипротонов, мюонов. Пучки ускоренных Π применяются в лучевой терапии.

Лит.: Резерфорд Э. Избр. научные труды, кн. 2 — Строение атома и искусственное превращение элементов, пер. с англ., М., 1972; Жак и о б М., Дэн и др. о ф Ф П., Внутренняя структура протона, «УФН», 1981, т. 133, в. 3, с. 505; «Физика», Лект. В., 1980, в. 238, Review of particle properties, С. А. Таширова.

ПРОТОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ — испускание протона при спонтанном распаде ядра. Возможные механизмы: 1) эмиссия запаздывающих протонов (ЗП) возбужденными дочерними ядрами, образовавшимися в результате *бета-распада* ядер (β^+) или электронного захвата (при этом энергия Q_β β^+ -распада больше энергии связи протона ϵ_p^0 в дочернем ядре, рис. 1); 2) про-

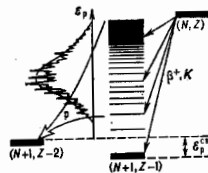


Рис. 1. Схема распада ядра с испусканием запаздывающего протона; (N, Z) — исходное ядро; $(N+1, Z-1)$ — промежуточное ядро; $(N+1, Z-2)$ — ядро, образовавшееся в результате испускания протона; ϵ_p^0 — энергия протона; схема — распределение вылетающих протонов по энергии.

тонный распад изомеров, происходящий, если энергия возбуждения изомера превышает ϵ_p^0 (см. *Изомерия ядерная*); 3) протонный распад ядра из основного состояния, аналогичный *альфа-распаду*; 4) носимые протоны ядра, четные по Z , за счёт спаривания протонов могут оказаться нестабильными относительно испускания двух протонов одновременно.

1. Излучатели ЗП открыты в ОИЯИ (Дубна) при облучении Ni ускоренным пучком ^{20}Ne (1962) и практически одновременно наблюдались для легких ядер (Мопрель). К 1991 открыто более 100 излучателей, самый легкий из к-рых ^9C (первое полураствора $T_{1/2} = 0,13$ с, самый тяжелый ^{183}Hg ($T_{1/2} = 8,8$ с). Величина $T_{1/2}$ лежит в пределах от $8,9 \cdot 10^{-9}$ с (^{10}O) до 70 с (^{84}Rh). Она определяется периодом β -распада исходного ядра; т. к. распад протонно-нестабильных состояний промежуточ-

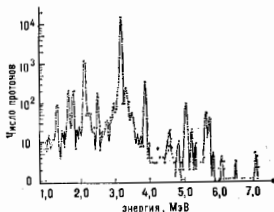


Рис. 2. Спектр запаздывающих протонов ^{22}Ar ($T_{1/2} = 0,17$ с; $W_p = 34\%$).

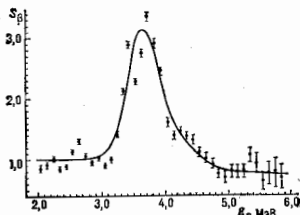


Рис. 3. Зависимость силовой функции β^+ -перехода для ^{22}Ar от энергии протона (для перехода к энергии возбуждения к ϵ_p^0 следует добавить $\epsilon_p^0 \approx 1$ МэВ).

ного ядра происходит за времена $\tau \sim 10^{-14} - 10^{-16}$. Вероятность W_p испускания ЗП достигает десятков % для лёгких элементов и уменьшается с ростом Z .

Исследование излучателей ЗП даёт информацию о свойствах ядер, удалённых от долины стабильности: об энергиях, спинах, изоспинах возбуждённых состояний, о ширине и плотности уровней, о характеристиках β -распада с большой энергией, а также о дефектах масс. Для излучателей с $Z \lesssim 25$ возможно спектроскопич. изучение уровней промежуточного ядра. Напр., в протонном ($T_{1/2} = 0,174$ с, $W_p = 34\%$) наиб. интенсивный пик ($\epsilon_p = 3,27$ МэВ) обязан распаду возбуждённого состояния ($T = 3/2$) ядра ^{80}Cl — изобарного аналога ^{80}Ar . Точное измерение вероятности перехода в аналоговое состояние позволяет определить его чистоту по изоспину. Это определено для ^{17}Ne , ^{20}S , ^{39}Ar , ^{64}Ti .

Для более тяжёлых ядер ($Z > 25$) спектр ЗП описывается соотношением

$$I(\epsilon_p) \propto (Q_\beta - \epsilon_p)^{c_p} S_p \Gamma_p \frac{S_p}{\Gamma_p}$$

где f — статистич. фактор β -распада, S_p — силовая функция (ср. квадрат матричного элемента перехода, отнесённый к единичному интервалу энергии возбуждения), Γ_p/Γ — отн. протонная ширина. Фактор f падает с ростом ϵ_p , а Γ_p/Γ растёт с ϵ_p в силу увеличения прозрачности кулоновского барьера для протонов. Это приводит к «скололообразной» структуре спектра ЗП (рис. 1, слева). Анализа спектров ЗП используют для определения S_p . Для этого эксперим. спектр сравнивают с расчётом в предположении $S_p = \text{const}$ (рис. 3). Граничная энергия спектра ЗП определяется разностью масс исходного и конечного ядер. Т. к. существующие теории описания ядерных масс согласуются с экспериментом вблизи области стабильности и расходятся при удалении от неё, то определение энергий распада удалённых ядер ценно для проверки этих моделей.

Полные ширины Γ протонно-нестабильных состояний находят по спектру квантов характеристического рентг. излучения в совпадении с ЗП. При К-захвате электронов ядром в К-оболочке образуется вакансия. Энергия испускаемого рентг. кванта зависит от того, когда произошла вылет протона: до заполнения электронной вакансии или после. Отношение интен-

сивностей этих квантов будет определять отношением времён жизни вакансии τ_v и протонно-нестабильного состояния промежуточного ядра $\tau = \hbar/\Gamma$. Рассчитав τ_v и зная вид рентг. спектра (в совпадении с ЗП), находят τ и, следовательно, полную ширину $\Gamma = \hbar/\tau$. Диапазон измеренных $\tau \approx 10^{-19} - 10^{-17}$ с.

Флуктуации интенсивности в спектре ЗП связаны с флуктуациями матричных элементов β -перехода и протонного распада. Для анализа этих флуктуаций развита статистич. модель, к-рая позволяет определить плотность уровней промежуточного ядра. Эта информация важна, т. к. относится к области удалённых

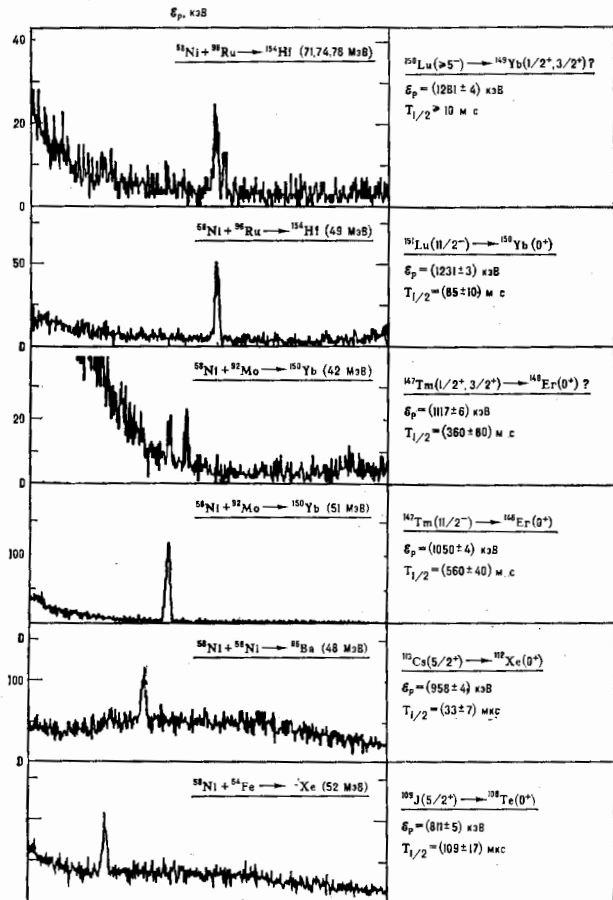


Рис. 4. Энергетические спектры, содержащие 6 протонов лишней, связанным с распадом из основного состояния. Для выделения протонных излучателей использовался сепаратор ядер отдачи на пучке ускорителя тяжёлых ионов (Дармштадт).

ядер и к диапазону энергий возбуждения 3—8 МэВ.

2. Протонно-активный изотоп ^{58m}Co (пока единственный), полученный в реакции $^{54}\text{Fe}(p, 2n)$, с периодом полураспада $T_{1/2} = 247$ мс испускает протон с $\epsilon_p = 1.59$ МэВ ($W_p = 1.5\%$). Время жизни относительно испускания протона $\tau_p = (P\tau_p)^{-1}$, где P_1 — прозрачность барьера для протона с орбитальным моментом l , γ_2 — приведенная ширина. При β -распаде ^{58m}Co происходит изменение волновой функции ядра, что приводит к уменьшению вероятности распада изомера, т. е. к увеличению времени его жизни.

3. Протонный распад из основного состояния возможен для более нейтронно-дефицитных ядер, чем эмиссия β . Из-за эффекта спаривания протонов он оказывается возможным сначала у четных ядер. Для регистрации β необходимо условие $\epsilon_{\text{мин}} < \epsilon_p < \epsilon_{\text{макс}}$, где $\epsilon_{\text{мин}}$ — выходящая конкуренцией со стороны β -распада ($\epsilon_{\text{мин}} \approx 0.1-1$ с), а $\epsilon_{\text{макс}}$ — быстрейшим измерит. методами. Интервал ϵ_p растёт с Z , что делает предпочтительным поиск β в области $Z > 50$.

Впервые слабая протонная активность с $\epsilon_p = 0.83 \pm 0.05$ МэВ и $T_{1/2} = (1.4 \pm 0.8)$ с наблюдалась при облучении ^{90}Ru пучком ^{32}S (ОИИИ, 1972). Она была объяснена распадом ^{121}Pr из основного состояния [реакция $^{90}\text{Ru}(^{32}\text{S}, p, 6n)^{121}\text{Pr}$]. В 1981 С. Хофманн (S. Hofmann) и др. (ФРГ) в реакции $^{88}\text{Ru}(^{68}\text{Ni}, p, 2n)$ получили ядра ^{111}Lu , k -рые с периодом $T_{1/2} = (85 \pm 10)$ мс испускают протоны с $\epsilon_p = 1.23$ МэВ. Сечение этой реакции в 700 раз больше, т. к. из-за использования пучка ^{68}Ni необходимый нейтронный дефицит достигается за счёт испарения только трёх нуклонов. В дальнейшем с помощью пучков ^{68}Ni открыто ещё 5 нуклидов, испытывающих распад из основного состояния (рис. 4). Время жизни определяется туннелированием протонов сквозь кулоновский и центробежный барьеры. Длина туннелирования для $\epsilon_p \approx 1$ МэВ составляет примерно 80 Фм.

4. При ϵ_p более значительно нейтронном дефиците для чётных по Z ядер за счёт спаривания протонов теоретически возможен вылет протонной пары (при устойчивости ядра к испусканию одного протона). Пока это явление не обнаружено, однако открыта т. н. бета-задержанная двухпротонная радиоактивность трёх излучателей на пучке ^{20}Ne : ^{22}Al (0.07 с), ^{26}P (0.02 с), ^{28}Si (0.05 с). Эти ядра испытывают т. н. сверхзарядный β -распад, после чего происходит последовательное испускание двух протонов.

Лит.: Карнаухов В. А., Петров Л. А. Ядра, удаленные от линии бета-стабильности. М., 1981; Particle emission from nuclei, ed. by M. S. Tiwari, D. N. Poenaru, v. 1—3, CRC Press, 1982; В. А. Исраелов.

ПРОТОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРТЕЛИ — линейный ускоритель, предназначенный для ускорения тяжёлых верлетнистических частиц (протонов, ионов). Отличается от линейного ускорителя лёгких частиц (электронов, позитронов) частотой ал.-магн. колебаний ускоряющего ВЧ-поля (метровый диапазон вместо дециметрового), устройством ускоряющих структур и существенно большими габаритами. См. *Линейные ускорители*.

ПРОТОННЫЙ СИНХРОТРОН — см. *Синхротрон протонный*.

ПРОТОН-ПРОТОННАЯ ЦЕПЧКА — см. *Водородный цикл*.

ПРОТУБЕРАНЦЫ (от лат. protuberans — выдающийся) — холодные ($T \lesssim 10^4\text{K}$) плотные образования внутри горячей ($T \gtrsim 10^6\text{K}$) разреженной короны Солнца. Они сильно различаются между собой по форме, структуре и времени жизни. Над солнечным лимбом П. наблюдаются в виде похожих на гигантские языки пламени потоков газа, чаще — в виде свещающихся аркад, k -рые состоят из множества отд. нитей и движущихся сгустков газа. В проекции на солнечный диск П. видны как тёмные изогнутые ленты сложной структуры, называе-

мые волокнами, соединённые между собой яркими образованиями — каналами волокон. Последние на лимбе проявляются в виде системы струй, соединяющих два или неск. П. Часто встречаются П., представляющие собой сложное переплетение волокон и протоков газа или каналов волокон.

Существует неск. классификаций П. по их топологии и степени динамич. активности. Основным является деление на два класса: спокойные и активные П. К классу спокойных (рис. 1) относятся долгоживущие (время жизни от 1 сут до неск. месяцев), медленно



Рис. 1. Типичный спокойный протубераец (снимок в линии H_α).

изменяющиеся, наблюдаемые вне активных областей П. Более короткоживущие, быстро взмывающиеся, связанные с активными областями и с солнечными пятнами П. относятся к классу активных (рис. 2). Спокойные П. делятся на два типа: расположенные ниже гелиографич. широты $40-45^\circ$ и расположенные выше этой



Рис. 2. Типичный активный протубераец (снимок в линии H_α).

широты (т. н. полярные П.). К классу активных П. относятся, в частности: П., связанные с солнечными вспышками (шестельные П.), П., связанные с солнечными пятнами, аруптивные П.

П. связаны с магн. полями на Солнце. Это используется для изучения солнечных магн. полей, особенно крупномасштабных. Их изменение в ходе цикла *солнечной активности* можно проследить по положениям спокойных П. Как правило, волокна располагаются над фотосферной нейтральной линией — границей раздела полярности вертикальной составляющей фотосферного магн. поля (см. *Вспышка на Солнце*). Магн. поля связывают П. практически со всеми проявлениями солнечной активности, включая вспышки, корональные транзиты (см. *Солнечная корона*), выбросы солнечной плазмы в межпланетную среду.

В спектрах П. наблюдаются линии излучения водорода, гелия, молибдена, кальция и др. металлов. Это позволяет оценить характерные значения параметров плазмы в П.: темп-ру и концентрацию, степень ионизации и возбуждения атомов, скорости гидродинамич. течений (направленных и хаотических), число атомов на луче зрения и многое другое. Кроме эмиссионных линий наблюдается излучение П. в непрерывном спектре. Оно обусловлено в основном рекомбинац. процессами и томоновским рассеянием фотосферного излучения на свободных электронах, что позволяет оценить полное число таких электронов на луче зрения.

Плазма в П. сильно неоднородна по темп-ре и плотности (концентрации частиц $10^{10}-10^{12}$ см $^{-3}$). По-видимому, имеется тенденция к выравниванию газового давления в горячих и холодных компонентах внутри П. Однако остаются небольшие градиенты давления, о чём свидетельствуют значительные хаотич. скорости даже в спокойных П. В П. часто происходит нестационарные явления типа «микровсплесков». Из анализа спектраль-

ных наблюдений следует также, что в плазме П. отсутствует *локальное термодинамическое равновесие*. Электронная темп-ра равна ионной, однако нет равенства между темп-рами возбуждения, ионизации, радиационной темп-ратурой.

Совр. наблюдения Солнца в оптич., радио-, УФ- и рентг. диапазонах не подтверждают существование ранее представления о механизмах формирования П. (в частности, т. н. силовых механизмах). Большое различие характерных времён развития П. наряду с многообразием наблюдаемых форм и структур, по-видимому, исключает возможность образования П. всех типов в результате действия единого механизма. Общим свойством механизмов формирования П. является конденсация корональной плазмы, обусловленная потерями тепловой энергии на излучение в условиях, когда теплопроводность частично подавлена магн. полем. Такой процесс соответствует конденсаци. моде тепловой неустойчивости. Он особенно эффективен в областях взаимодействия магн. потоков, где происходит их перераспределение типа магн. *пересоединения*.

Лит.: Сомов Е. В., Сыроватский С. И., Тепловая неустойчивость внешнего слоя как причина образования холодных нитей в солнечной короне, «Известия в астрономии», ж., 1980, т. 6, № 9, с. 582; Demoulin P. и др., Fine structures in solar filaments, «Astron. Astrophys.», 1987, v. 183, № 1, p. 142. А. И. Курчатов.

ПРОЦЕССОР (англ. processor, от process — обработать) — устройство и (или) программа обработки информации, функционирующей в составе ЭВМ. Как правило, аппарату П. реализуется в виде одного или неск. микропроцессоров. Аппаратные характеристики П. аналогичны характеристикам микропроцессоров.

По выполняемым ф-циям П. классифицируются на центральные, периферийные, ввода-вывода, коммуникационные и специализированные.

Центральны́й П. (ЦП) — основная часть ЭВМ, определяемая как совокупность арифметико-логич. устройств (АЛУ), устройств управления и, как правило, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ, см. *Данные устройств*). АЛУ — часть ЦП, реализующая набор основных арифметич. и логич. операций над данными, поступающими на вход АЛУ. Результат выполнения операции подается на выход АЛУ. Устройство управления — часть ЦП, обеспечивающая контроль за передачей и собственно передачу данных между ОЗУ, АЛУ и др. частями компьютера.

Периферийны́й наз. П., подключаемый к ЭВМ с помощью каналов ввода-вывода. Используется в составе вычислит. системы наряду с ЦП для увеличения её вычислит. производительности и распределения вычислит. ф-ций. Как правило, высокопроизводительные вычислит. системы содержат несколько (10 и более) периферийных П., позволяющих проводить одновременно (параллельную) обработку информации.

П. ввода-вывода предназначен для обслуживания работы устройств ввода-вывода информации. Часто включает наряду с аппаратурой программы обслуживания разл. ф-ций конкретного устройства.

Коммуникационны́й наз. П. ввода-вывода, используемый для контроля и передачи данных по коммуникац. линиям в соответствии со стандартизованными правилами передачи данных (протоколами). Используется для организации связи между компьютерами и периферийными удалёнными устройствами (в т. ч. и для организации т. н. электронной почты).

Специализированны́й наз. П., специально сконструированный для решения конкретной задачи, напр. выполнения прямого и обратного фурыпреобразований (фуры-процессор). Обычно к специализированным П. относят матем. П. (реализуют аппаратно выполнение арифметич. операций с большой точностью, вычисление стандартных ф-ций и т.п.), П. обработки текстов и изображений. Последние два типа П. наряду с аппаратурой включают, как правило, и мощное программное обеспечение. Иногда программное

обеспечение может полностью выполнять ф-ции аппаратного П. В этом случае оно также наз. П.

Лит.: Майерс Г. Р. Архитектура современных ЭВМ, пер. с англ., кн. 1—2, М., 1985; Королёв Л. П., Микропроцессоры, микро- и мини-ЭВМ, М., 1988. В. Н. Забыв.

ПРОЧНОСТИ ПРЕДЕЛ — напряжения или деформации, соответствующие максимальной (до разрушения образца) значению нагрузки (мера прочности материала). При растяжении цилиндрчик, образца из металла разрушению (разрыву) обычно предшествует образование шейки, т. е. местное уменьшение поперечных размеров образца, при этом необходимая для деформации растягивающая сила уменьшается. Отношение наиб. значения растягивающей силы к площади поперечного сечения образца до нагружения наз. условный П. п. или временный сопротивление. Истинный П. п. наз. отношение значения растягивающей силы непосредственно перед разрывом к наименьшей площади поперечного сечения образца в шейке. При одноосном растяжении условный П. п. меньше истинного. В хрупких материалах местное уменьшение поперечных размеров перед разрывом незначительно и поэтому величии условного П. п. и истинного П. п. различаются мало. При продольном сжатии цилиндрчик, образца разрушению не предшествует уменьшение сжимающей силы. Условный и истинный П. п. при этом вычисляются как отношения значения сжимающей силы непосредственно перед разрушением к начальной (до сжатия) площади поперечного сечения и к площади сечения при разрушении соответственно. При кручении толстоственного трубчатого образца определяется П. п. при сдвиге как наибольшее касательное напряжение, предшествующее разрушению образца.

В сложном напряжённом состоянии П. п. определяется как значение нек-рой комбинации компонентов тензора напряжений или тензора деформации перед разрушением. При этом, вообще говоря, значение П. п. зависит от процесса деформации, т. е. от порядка приложения нагрузок. В нек-рых материалах разрушение наступает, когда наибольшее растягивающее напряжение достигает предельного значения; в других — когда предельного значения достигает наибольшее касательное напряжение; в третьих — когда предельного значения достигает интенсивность напряжений, и т. н. Выбор П. п. зависит как от свойств материала, так и от требований, предъявляемых к конструкции. Напр., в ряде случаев в конструкции недопустимо возникновение пластич. деформаций. При этом для определения П. п. используются условия пластичности.

Значение П. п. зависит от внеш. условий, напр. от темп-ры, гидростатич. давления, наличия химически агрессивной среды. См. также *Прочность дилатемная*.

В. С. Лемский.

ПРОЧНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНАЯ — разрушение материала не тотчас после приложения нагрузки, а по истечении нек-рого времени. При этом разрушению предшествует б. или м. заметная деформация *получности материалов* (см. также *Прочность твёрдых тел*). Явление П. д. позволяет использовать конструкцию в течение ограниченного (может быть, очень короткого, но достаточного для выполнения заданной ф-ции) времени при больших нагрузках, существенно превышающих нагрузки, допустимые при длит. эксплуатации.

П. д. характеризуется временем до разрушения при фиксированном напряжённом состоянии и при заданной темп-ре. Напр., в опытах с растяжением цилиндрчик, образца строят кривые П. д., по к-рым определяется время до разрушения при заданном нормальном напряжении в поперечном сечении для разных значений темп-ры испытаний (рис.). Чем больше напряжение σ , тем меньше времени проходит до разрушения. Для конструирования часто важно знать деформацию в момент, непосредственно предшествующий разрушению. Обычно чем больше время до разрушения, тем меньше накопленная деформация ползучести. В слож-



ном напряжённом состоянии кривую П. д. можно строить, напр., как зависимость времени до разрушения от интенсивности напряжений. Для определения характеристик П. д. при изменяющихся во времени нагрузках пользуются теорией, основанной на понятии накопления в материале микроскопич. повреждений.

Исследование П. д. важно для определения времени безопасного функционирования (ресурса) конструкции и решения проблемы наименьшего веса конструкции. См. также *Западмание текучести*. В. С. Ленский.

ПРОЧНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ — в широком смысле способность твёрдых тел сопротивляться разрушению (разделению на части), а также необратимую изменению формы (пластич. деформация) под действием внеш. нагрузок. В узком смысле — сопротивление разрушению.

В зависимости от материала, вида напряжённого состояния (растяжение, сжатие, изгиб и др.) и условий эксплуатации (тем-ра, время действия нагрузки и др.) в технике приняты разл. меры П. т. т. (предел текучести, временное сопротивление, предел усталости и т. д.). Разрушение твёрдого тела — сложный процесс, зависящий от мн. факторов, поэтому величины, определяющие П. т. т., являются условными.

Физическая природа прочности. П. т. т. обусловлена в конечном счёте силами взаимодействия между атомами или молекулами, составляющими тело. Напр., сила взаимодействия двух соседних атомов (если пренебречь влиянием окружающих атомов) зависит лишь от расстояния между ними (рис. 1). При равновесном расстоянии $r_0 \approx 0,1$ нм (1 Å) эта сила равна нулю. При меньших

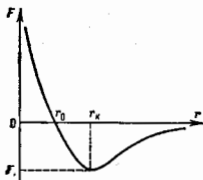


Рис. 1. Зависимость силы взаимодействия двух атомов от расстояния между ними.

расстояниях сила положительна и атомы отталкиваются, при больших — притягиваются. На критич. расстоянии r_k сила притяжения по абс. величине максимальна и равна F_t . Напр., если при растяжении цилиндрич. стержня с поперечным сечением S_0 действующая сила P , направленная вдоль его оси, такова, что приходится на данную пару атомов внеш. сила превосходит макс. силу притяжения F_t , то атомы беспрепятственно удаляются друг от друга. Однако, чтобы тело разрушилось вдоль нек-рой поверхности, необходимо, чтобы все пары атомов, расположенные по обе стороны от рассматриваемой поверхности, испытывали действие силы, превосходящей F_t . Напряжение, отвечающее силе F_t , наз. теоретич. прочностью на разрыв σ_t ($\sigma_t \approx 0,1 E$, где E — модуль Юнга). Однако на практике наблюдается разрушение при нагрузке P^* , к-рой соответствует напряжение $\sigma = P^*/S$ в 100—1000 раз меньше σ_t . Расхождение теоретич. П. т. т. с действительной объясняется неоднородностями структуры тела (границы зёрен в поликристаллич. материале, пограничные включения и др.), из-за к-рых нагрузка P распределяется неравномерно по сечению тела.

Механизм разрушения. Если на участке поверхности малых размеров (во значительно превышающих сече-

ние одного атома) локальное напряжение окажется больше σ_t , вдоль этой площадки произойдёт разрыв. Край разрыва разойдётся на расстояние, большее r_k , на к-ром межатомные силы уже малы, и образуется микротрещина (рис. 2). Зарождению микротрещин при напряжении ниже от способствуют термич. флуктуации.

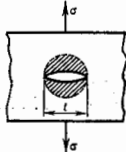


Рис. 2. Трещина Гриффита; заштрихована область, в которой сняты напряжения. Стрелки указывают направление напряжения.

Локальные напряжения особенно велики у края разовавшейся трещины, где происходит концентрация напряжений, причём они тем больше, чем больше её размер. Если этот размер больше нек-рого критич. r_c , на атомы у края трещины действует напряжение, превосходящее σ_t , и трещина растёт дальше по всему сечению тела с большой скоростью — наступает разрушение. Величина r_c определяется из условия, что освобождаясь при росте трещины упругая энергия материала покрывает затраты энергии на образование новой поверхности трещины: $r_c \approx E \mu \sigma^{-2}$ (где μ — энергия единицы поверхности материала). Прежде чем возрастающее внеш. усилие достигнет необходимой для разрушения величины, отд. группы атомов, особенно входящие в состав дефектов в кристаллах, обычно испытывают перестройки, при к-рых локальные напряжения уменьшаются («релаксируют»). В результате происходит необратимое изменение формы тела — пластич. деформация; ей также способствует термич. флуктуация. Разрушению всегда предшествует большая или меньшая пластич. деформация. Потому при оценке r_c в энергию U должна быть включена работа пластич. деформации U^p . Если пластич. деформация велика не только вблизи поверхности разрушения, но и в объёме тела, то разрушение и в к-ром. Разрушение без заметных следов пластич. деформации наз. хрупким и х. Характер разрушения определяется в структуре поверхности излома. В кристаллич. телах хрупкому разрушению отвечает скол по кристаллографич. плоскостям спайности, вязкому — слияние микроступов и скольжение. При низкой тем-ре разрушение протеч. хрупкое, при высокой — вязкое. Тем-ра перехода от вязкого к хрупкому разрушению наз. критич. тем-рой хладоломкости.

Поскольку разрушение есть процесс зарождения и роста трещин и пор, оно характеризуется скоростью или временем τ от момента приложения нагрузки до момента разрыва, т. е. долговечностью материала. Исследованиями кристаллич. и аморфных тел показали, что в широком интервале тем-р T и напряжений σ , применённых к образцу, долговечность при растяжении определяется соотношением

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{U_0 - \sigma V}{kT}\right), \quad (1)$$

где τ_0 прибл. равно периоду тепловых колебаний атомов в твёрдом теле (10^{-12} с), энергия U_0 близка к энергии сублимации материала, актив. объём V составляет обычно неск. тысяч атомных объёмов и зависит от структуры материала, сформировавшейся в процессе предвартельной термич. и механич. обработки и во время нагружения. При низких тем-рах долговечность очень резко падает с ростом напряжения, так что при любых важных для практики значениях τ существует почти постоянное предельное значение напряжения σ_0 , выше к-рого образец разрушается практически мгновенно, а

ниже — живёт неограниченно долго. Это значение σ_0 можно считать *пределом прочности* (табл.).

Некоторые значения предела прочности на растяжение, кгс/мм² (1 кгс/мм² = 10 МН/м²)

	σ_0	σ_0/E
Графит (нитевидный кристалл)	2400	0,024
Сапфир (нитевидный кристалл)	1500	0,028
Железо (нитевидный кристалл)	1300	0,044
Титанов проволока на высокоуглеродистой стали	420	0,02
Титанов проволока из вольфрама	380	0,009
Остеповолонит	360	0,035
Мягкая сталь	60	0,003
Нейлон	50	

Время τ затрачивается на ожидание термофлуктуации зарождения микротрещины и на их рост до критич. размера r_c . Когда к образу прикладывают напряжение σ , он деформируется сначала упруго, затем пластически, причём около структурных неоднородностей, имевших в исходном состоянии или возникших при пластич. деформации, образуются большие локальные напряжения (напр., в кристаллах — в результате скопления дислокаций). В этих местах зарождаются микротрещины. Их концентрация может быть очень большой (напр., в нек-рых ориентиров. полнмерах до 10^{13} трещин в 1 см²). Однако их размеры, определяемые масштабом структурных неоднородностей, значительно меньше r_c . Под пост. напряжением размеры и концентрации трещин растут медленно и тело не разрушается, пока случайно (напр., в результате последоват. снятия близко расположенных соседних трещин) одна из них не достигнет до критич. размера. Поэтому при создании прочных материалов следует заботиться не столько о том, чтобы трещины не зародились, сколько о том, чтобы они не росли.

Случайное распределение структурных неоднородностей по объёму образца, по размерам и по степени прочности и случайный характер термич. флуктуаций приводит к разбросу значений долговечности (а также предела П. т. т. σ_0) при испытании одинаковых образцов при заданных значениях σ и T . Вероятност. встретить в образце слабое место тем больше, чем больше его объём. Поэтому П. т. т. (разрушающее напряжение) малых образцов (напр., тонких нитей) выше, чем больших на того же материала (т. е. масштабный эффект). Участки с повышенным напряжением, где легче зарождаются микротрещины, встречаются чаще у поверхности (выступы, царапины). Поэтому полровка поверхности и защитные покрытия повышают П. т. т. Напротив, в агрессивных средах П. т. т. понижается.

Лит.: Гуль В. Е., Структура и прочность полимеров, 3 изд. М., 1978; Разрушение, пер. с англ., т. 1, М., 1973; Редель В. Р., Суть и природа И., Томашевич И. Э. Е., Кинематическая природа прочности твёрдых тел, М., 1974.

ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ — визкотемпературный механизм проводимости в полупроводниках, при к-ром перенос заряда осуществляется путём ивантовских туннельных переходов (прыжков) носителей заряда между разл. локализованными состояниями. Прыжки сопровождаются поглощением или излучением фононов. Наиб. изучена П. п. в слаболегированном кристаллич. полупроводнике, где происходит туннелирование между примесным электронным состоянием, а также в аморфных и стеклообразных полупроводниках, в к-рых носители заряда туннелируют между локализов. состояниями хвоста плотности состояний в квазизапрещённой зоне.

Слаболегированным наз. кристаллич. полупроводник (для определённости л-типа), в к-ром концентрация доноров N_D мала по сравнению с концентрацией, при к-рой происходит переход металл — диэлектрик. В таких случаях перекрытие электронных оболочек соседних доноров мало. Поэтому каждый донор можно рассмат-

ривать как водородоподобный атом, внеш. электрон к-рого находится на расстоянии борновского радиуса $a \approx 0,5 \cdot 10^{-8}$ см и имеет энергию связи с ядром $\epsilon_{св} \approx 13,6$ эВ. В таких полупроводниках переход к П. п. происходит при низких темп-рах ($T \sim 10$ К), когда вероятность термоактивации электрона донора в зону проводимости (для определённости рассматриваем полупроводник л-типа) становится много меньше вероятности его туннелирования на соседний незанятый донор. На графике зависимости логарифма проводимости δ от $1/T$ атому переходу соответствует излом — энергия активации проводимости меняется от $\epsilon_F - \epsilon_D$ до ϵ_D , равной по порядку величин ширине примесной зоны ϵ_c — дна зоны проводимости).

Т. к. электрон может прыгать только с занятого донора на свободный, необходимым условием П. п. является наличие свободных мест в примесной зоне, к-рые при низких темп-рах может быть обеспечено лишь компенсацией, т. е. введением акцепторной примеси, захватывающей часть электронов с доноров.

Модель сетки сопротивлений. При термодинамич. равновесии частоты Γ_{ij} туннельных переходов электрона с донора i на донор j и обратно (Γ_{ji}) равны между собой и определяются соотношением

$$\Gamma_{ij} = \gamma_0 \exp(-\xi_{ij});$$

$$\xi_{ij} = \frac{2r_{ij}}{a} + \frac{\epsilon_{ij}}{kT}. \quad (1)$$

Здесь $\gamma_0 \approx 10^{12}$ Гц (частота порядка фононов), r_{ij} — расстояние между донорами, a — радиус локализации волновой ф-ции электрона,

$$\epsilon_{ij} = \begin{cases} (\epsilon_i - \epsilon_j) - \frac{e^2}{\epsilon r_{ij}} & \text{при } (\epsilon_i - \epsilon_F)(\epsilon_j - \epsilon_F) < 0, \\ \max\{|\epsilon_i - \epsilon_F|, |\epsilon_j - \epsilon_F|\} & \text{при } (\epsilon_i - \epsilon_F)(\epsilon_j - \epsilon_F) > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Здесь ϵ_i, ϵ_j — энергии электрона на донорах, ϵ — диэлектрич. проницаемость. Первое слагаемое в (1) связано с зависимостью от r_{ij} матричного элемента электронно-фононного взаимодействия, второе — с малой вероятностью найти фонон с энергией больше kT , необходимой для перехода.

Внеш. электрич. поле E нарушает баланс между Γ_{ij} и Γ_{ji} по двум причинам: 1) за счёт действия самого поля и за счёт изменения зарядового состояния соседних примесей меняются энергии доноров, а с ними и энергия фонона, необходимого для прыжка; 2) поле, перераспределяя электроны, меняет среднее по времени числа заполнения доноров, что можно описать введением для каждого донора локального квазиуровня Ферми $\epsilon_F^i, \epsilon_F^j$. В результате между донорами возникает электрич. ток, пропорциональный электрич. полю E (линейное приближение):

$$I_{ij} = (U_i - U_j)/R_{ij}, \quad (3)$$

где $U_i = -(E r_i + \epsilon_F^i/e)$ — электрхим. потенциал. Можно показать, что

$$R_{ij} = \frac{kT}{e^2 \gamma_0} \exp \xi_{ij}. \quad (4)$$

Т. о., задача о вычислении прыжковой электропроводности полупроводника сводится к задаче о проводимости эквивалентной сети сопротивлений (сетки Миллера и Абрахамса), узлы к-рой соответствуют локализованным состояниям (донорам), а сопротивления, включённые между узлами, задаются (4).

Важнейшим свойством сетки Миллера и Абрахамса является экспоненциально широкий разброс входящих в неё сопротивлений: для слаболегированного полупроводника значения только первого слагаемого в (1) для доноров, отстоящих на среднем и двух средних расстояниях, отличаются примерно в 10, а соответствую-

щие сопротивления R_{ij} в e^0 (в $2.2 \cdot 10^4$) раз. Поэтому для вычисления проводимости всей сетки необходимо использовать методы протекания теории, к-рые дают выражение для проводимости:

$$\delta \approx \frac{e^2 v}{kT} \exp(-\xi_c). \quad (5)$$

Здесь ξ_c — т. н. порог протекания по случайным узлам с критерием связности $\xi_{ij} \leq \xi_c$, при к-ром все пары доноров с $\xi_{ij} \leq \xi_c$ образуют бесконечный кластер, пронизывающий весь образец. Длина кластера

$$L \approx r_h \xi_c^v, \quad (6)$$

где r_h — ср. длина прыжка, а v — критич. индекс, зависящий от размерности решетки: $v_2 = 1.33$, $v_3 = 0.88$.

Наиб. просто задача о вычислении ξ_c решается для относительно высоких темп-р, когда для типичной пары ближайших доноров с $r_{ij} = N_d^{-1/3}$ первое слагаемое в (4) много больше второго. В этом случае

$$\xi_c = 2r_{ij} e^2 / \epsilon_0 kT, \quad (7)$$

где $r_c = 0.865 N_d^{-1/3}$ — т. н. перколяционный радиус, а $\epsilon_0 = \langle \epsilon_{ij} \rangle$. Ср. энергия $\langle \epsilon_{ij} \rangle$ определяется легированием и степенью компенсации образца $K = N_A / N_D$ (N_A — концентрация акцепторов):

$$\langle \epsilon_{ij} \rangle = (e^2 N_d^{1/3} / \epsilon_0) \cdot F(K). \quad (8)$$

Здесь $F(K)$ — безразмерная ф-ция (табулирована).

При $K \rightarrow 0$ величина $F(K) = 0.99$; при росте степени компенсации $F(K)$ сначала убывает, проходит через минимум при $K \approx 0.5$ и возрастает как $(1 - K)^{-1/4}$ при $K \rightarrow 1$. При $K < 1$ ф-ла (7) справедлива при $T < T_{кр} \equiv \epsilon_0 / k \ln(1/K)$, а при $T > T_{кр}$ проводимость зависит от T лишь степенным образом.

Прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка. При низких темп-рах, когда $\epsilon_0 / kT > 2r_{ij} e^2$, а значит, вклад в П. п. дают не все локализов. состояния примесной зоны, а только их небольшая часть, попадающая в «оптимальную» энергетич. полосу $\pm \xi_c kT$ вокруг уровня Ферми. При уменьшении T ширина оптим. полосы уменьшается (несмотря на рост ξ_c), а расстояния между попавшими в неё локализов. состояниями растут; П. п. в этом режиме наз. П. п. с переменной длиной прыжка (VPH — variable range hopping). Если плотность состояний $g(\mathcal{E})$ постоянна внутри полосы, то для ξ_c справедлив закон Мотта:

$$\xi_c = (T_0 / T)^{1/(1+\nu)}, T_0 = \beta_0 d / (g(\mathcal{E}_F) k a^2), \quad (9)$$

где d — размерность пространства, коэф. $\beta_0 = 13.8$, $\beta_2 = 24.2$.

В слаболегированных полупроводниках, где основной причиной разброса энергетич. уровней является кулоновский потенциал заряженных примесей, плотность состояний на уровне Ферми квадратично обращается в 0 (кулоновская щель). В этом случае

$$\xi_c = (T_0 / T)^{1/(1+\nu)}, T_0 = \beta_2 d^2 e^2 (k e a), \quad (10)$$

где $\beta_2 = 6.2$, $\beta_3 = 2.8$.

Прыжковая проводимость в аморфных полупроводниках практически всегда носит характер VPH и наблюдается при значительно более высоких темп-рах, чем в слаболегированных кристаллич. полупроводниках, из-за большей плотности состояний. Вид зависимости $\sigma(T)$ определяется структурой $g(\mathcal{E})$ и сильно зависит от материала и способа приготовления образца. У многих аморфных полупроводников наблюдается максимум (10).

Неомические эффекты в П. п. наступают в электрич. полях, когда напряжение eEL , падающее на корреля-

ционной длине бесконечного кластера, становится больше или порядка kT , и для критич. сопротивлений сетки Миллера и Абрахамса оказываются неверным выражение (3), полученное разложением по малому параметру eU/kT . При $T \ll \epsilon_0 / kT$ и в области VPH электропроводность $\sigma(E) \approx j(E)/E$ экспоненциально растёт с полем. Для $E > E_c \equiv kT/eL$ в пределе $\xi_c \gg 1$

$$\sigma(E) \approx \sigma(0) \exp [C \sqrt{eEL/kT}], \quad (11)$$

где C — численный коэф. Выражение (11) справедливо для $\xi_c > 30$, а при соответствующих эксперименту значениях $\xi_c \approx 10$ –20 зависимость $\ln[\sigma(E)/\sigma(0)]$ от E близка к линейной.

Прыжковая проводимость в переменном электрическом поле связана со смешением носителей лишь на конечные расстояния. Поэтому при частоте поля $\omega > \sigma$ проводимость определяется не бесконечным кластером, а переходами электронов между парами конечных кластеров, состоящих из доноров, связанных сопротивленными с $\xi_{ij} < \xi(\omega) \equiv \ln(\nu_j \omega)$. При больших частотах, когда разница $\xi_c - \xi(\omega)$ становится не мала по сравнению с ξ_c , проводимость определяется поглощением энергии в изолиров. парах локализованных состояний. При относительно малых частотах и высоких темп-рах, когда $\hbar \omega \ll kT$, основным механизмом поглощения являются релаксац. потери, а при $\hbar \omega \gg kT$ — резонансное (бесфоновое) поглощение фотонов.

Лит.: Шкловский В. И., Неомическая прыжковая проводимость, «ФТД», 1978, т. 10, в. 8, с. 1440; Шкловский В. И., Эфрос А. Л., Электронные свойства легированных полупроводников, М., 1978; Нгуен Ван Диев, Шкловский В. И., Эфрос А. Л., Энергия активации примесной проводимости слабо легированных полупроводников, «ФТД», 1978, т. 13, с. 2192; Вятки И. П., Квантовые эффекты в неупорядоченных полупроводниках, М., 1984, с. 107–110. Э. И. Лезин.

ПРЯМОЗОННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ — полупроводники, в энергетич. спектре к-рых «потоки» валентной зоны \mathcal{E}_v и дна зоны проводимости \mathcal{E}_c соответствуют одному и тому же значению квазиимпульса. Межзонное поглощение эл.-магн. излучения в П. п. сопровождается прямыми (пертикальными) переходами электронов из валентной зоны в зону проводимости без изменения квазиимпульса, поскольку волновой вектор фотона наперемежку мал по сравнению с вектором обратной решетки. К П. п. относятся GaAs, InSb и др. Э. М. Струтин.

ПРЯМЫЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ — процессы, в к-рых входящая в ядро энергия передается преим. одному или небольшой группе нуклонов. П. я. р. вызываются всевозможными налетающими на ядро частицами — от γ -квантов до многозарядных ионов, но всем доступным диапазоном энергий (до неск. ГэВ). Для П. я. р. характерны сильная угл. анизотропия вылета частиц и сравнительно слабая зависимость сечения σ от энергии налетающих частиц \mathcal{E} . Ядро, образующееся в результате П. я. р., находится, как правило, либо в слабо возбужденном, либо в основном состоянии.

П. я. р. были открыты в нач. 50-х гг. 20 в. Первыми были обнаружены реакции дейтронного срыва а (d, p) и p о d в а t а (p, d) на лёгких ядрах. Образующиеся в этих реакциях протоны и дейтроны вылетают в основном вперёд (в направлении пучка налетающих частиц). Известны П. я. р. в к-рых нуклон или группа нуклонов переходит от одного из сталкивающихся ядер к другому (реакции передачи), реакции квазиуруного рассеяния ($p, 2p$), процессы с выбиванием из ядра дейтронов, т. е. реакции (p, pd) и т. д.

Особенности П. я. р. могут быть объяснены, если допустить, что вылетающие из ядра частицы получили энергию и импульс в процессе непосред. взаимодействия с налетающей частицей. Предполагается, что П. я. р. происходят на периферии ядра, где плотность нуклонов мала, вследствие чего частица, получившая достаточную энергию от внеш. агента, имеет

значит, вероятность покончить ядро, Т. к. протяжённость периферийного слоя порядка 10Φ , а радиус ядра тяжёлых ядер составляет 10Φ (см. *Ядро атома*), то отсюда вероятность П. я. р. должна быть $\sim 10\%$ (у лёгких ядер несколько больше), что согласуется с экспериментом.

Количество теория П. я. р. была предложена С. Т. Батлером (S. T. Butler) в 50-х гг., впервые применительно к реакциям сыра. Она основывалась на представлении о потенциальном взаимодействии налетающей частицы с нуклонами ядра. В 60-х гг. была сформулирована дисперсионная теория, основанная на использовании методов *квантовой теории поля* (фeyнмановской диаграммой тельхики). Она даёт возможность выразить вероятность П. я. р. через константы, характеризующие ядро (напр., эфф. число частиц данного сорта на периферии ядра) и амплитуды вероятности элементарного акта взаимодействия налетающей и внутряядерной частиц.

П. я. р. используются для изучения спектра ядерных уровней, структуры периферии ядра (в частности, периферийных коррелиров, групп нуклонов — кластеров, см. *Нуклонная ассоциативная модель*) и получения данных о взаимодействиях нестабильных элементарных частиц с нуклонами.

Лит.: Вальтер С. Ядерные реакции сыра, пер. с англ., М., 1960; Шапиро И. С., Теория прямых ядерных реакций, М., 1963; его же, Некоторые вопросы теории ядерных реакций при высоких энергиях, «УФН», 1967, т. 92, в. 4, с. 549; Колябин В. В., Дельсиль Г. А., Шапиро И. С., Механизм прямых реакций при высоких энергиях, «УФН», 1974, т. 113, в. 2, с. 239.

И. С. Шапиро

ПСЕВДОВЕКТОР — то же, что **аксиальный вектор**.
ПСЕВДОВЕКТОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО — вещественное линейное пространство, снабжённое неположительно определённым скалярным произведением (a, b) . Для П. п. размерности n и индекса r аксиоматически определены скалярного произведения *евклидова пространства* заменяется следующей: существуют n векторов $a_i, i = 1, \dots, n$, таких, что

$$(a_i, a_j) = 0, i \neq j; (a_k, a_k) > 0, k \leq r; (a_k, a_k) < 0, k > r.$$

Пара чётная (p, q) , где $q = n - p$, наз. сигнатурой П. п., обозначаемого $E_{p,q}$ (или $R_{p,q}$). Для физики особенно важно *Минковского пространство — время* $E_{1,3}$, фигурирующее в специальной теории относительности.

В П. п. можно ввести основные операции векторного и тензорного анализа, в частности *инвариантную метрику*. Координаты, в k -рых метрич. тензор g_{ij} имеет вид

$$g_{ij} = 0, i \neq j; g_{kk} = 1, k \leq p; g_{kk} = -1, k > p,$$

наз. псевдоевклидовыми. В них скалярное произведение принимает вид

$$(a, b) = g_{ik} a^i b^k = a^1 b^1 + \dots + a^p b^p - a^{p+1} b^{p+1} - \dots - a^n b^n.$$

Псевдоевклидов квадрат длины вектора в П. п., в отличие от евклидова, может быть отрицательным, а также нулевым (изотропные векторы). Совокупность изотропных векторов образует изотропный конус.

Движения П. п. образуют $(n+1)/2$ -мерную группу (для $E_{1,3}$ — Пуанкаре группа) и в псевдоевклидовых координатах записываются в виде

$$x' - x' = \Lambda x + a,$$

где a — вектор трансляции, Λ — $n \times n$ -матрица поворотов, такая, что $(a, b) = (\Lambda a, \Lambda b)$. Метрику П. п. можно получить из метрики евклидова пространства формальной заменой:

$$z^2 = y^2, j \leq p; z^2 = -y^2, j > p.$$

Кривизны тензор П. п. тождественно равен нулю: как и евклидово, оно плоское.

Лит.: Ефимов Н. В., Высшая геометрия, 6 изд., М., 1978; Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фомин А. Т., Современная геометрия, 2 изд., М., 1986; Новиков С. П., Фомин А. Т., Элементы дифференциальной геометрии и топологии, М., 1987.

А. М. Малюков

ПСЕВДОСКАЛЯРНАЯ ЧАСТИЦА — элементарная частица, характеризующаяся нулевым спином и отрицательной *внутренней чётностью* (см. *Скалярное поле*).
ПСЕВДОСКАЛЯРНОЕ ПОЛЕ — см. *Скалярное поле*.
ПСЕВДОТЕНЗОР (относительный тензор) в s и ω — многокомпонентная величина P , определяемая в каждой координатной системе x^i ω порядковыми компонентами, k -рые при переходе к новой, штрихованной, системе координат преобразуются по закону:

$$P_{i_1 i_2 \dots i_s}^{k_1 k_2 \dots k_r} = \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x^{i_1}} \frac{\partial x^{k_2}}{\partial x^{i_2}} \dots \frac{\partial x^{k_r}}{\partial x^{i_r}} \times \times \frac{\partial x^{m_1}}{\partial x^{i_1}} \frac{\partial x^{m_2}}{\partial x^{i_2}} \dots \frac{\partial x^{m_\omega}}{\partial x^{i_\omega}} P_{m_1 m_2 \dots m_\omega} \left[\frac{\partial(x^1, \dots, x^n)}{\partial(x^1, \dots, x^n)} \right]^\omega,$$

где ω — целое число, $\omega \neq 0$ (при $\omega = 0$ величина P есть *тензор тензор*), $\omega = 0$ ($\partial(x^1, \dots, x^n)/\partial(x^1, \dots, x^n)$) — якобиан преобразования старых (нестрихованных) координат в новые (штрихованные). (При $\omega = +1$ П. наз. тензорной плотностью ω). Этот П. называется r раз контравариантным и s раз ковариантным. Над П. можно совершать те же алгебраич. действия, что и над тензорами. Сумма двух П. одинакового порядка, вариантиности и веса является П. того же порядка, вариантиности и веса. Внеш. произведением двух П. A и B веса ω_A и ω_B с компонентами $A_{i_1 \dots i_p}^{a_1 \dots a_p}$ и $B_{j_1 \dots j_q}^{b_1 \dots b_q}$ (быть может, различного строения) наз. П. $C = AB$, $(n+p+r)$ раз контравариантный и $(m+q)$ раз ковариантный веса $\omega_A + \omega_B$ с компонентами

$$C_{i_1 \dots i_{p+q}}^{a_1 \dots a_p b_1 \dots b_q} = A_{i_1 \dots i_p}^{a_1 \dots a_p} B_{i_{p+1} \dots i_{p+q}}^{b_1 \dots b_q}.$$

Примерами П. являются *Левы-Числты символы*: $\epsilon_{1,2,3,4}$ с весом $\omega = -1$ и $\zeta_{1,2,3,4}$ с весом $\omega = 1$. Примеры П. в физике — угл. скорость, вихрь векторного поля.

С. И. Лоанов

ПСИ-ЧАСТИЦЫ (ψ -частицы) — общее наз. группы нейтральных мезонов со спином 1 и отрицательной *внутренней чётностью*, имеющих близкие свойства и значения масс, лежащие в интервале 3–4 ГэВ. П.-ч. — *истинно нейтральные частицы*; их *зарядовая чётность* $C = -1$.

Первая из этой группы частиц (т. е. J/ψ -частица) с массой ок. 3,1 ГэВ открыта в 1974 году почти одномоментно двумя коллективами физиков: С. Тингом (S. Ting) с сотрудниками [1] при изучении спектра масс электрон-позитронных пар, образующихся в столкновении $p + p$ при энергии падающих протонов 30 ГэВ; Б. Рихтером (B. Richter) с сотрудниками [2] в экспериментах на астречных электрон-позитронных лучках при исследовании энергетич. зависимости сечения аннигиляции 2.4 – 4.8 ГэВ. В обоих случаях чётко проявилось существование тяжёлого мезона со спином 1, распадающегося в канал $e^+ e^-$: в первом эксперименте — по наличию пика в спектре масс $e^+ e^-$ -пар, во втором — по наличию резонанса в энергетич. зависимости сечения при $E_{с.ц.и.} = 3.1$ ГэВ. (Обозначения J и ψ принадлежат соответственно 1-й и 2-й группам экспериментаторов, с чем и связано двойное название частицы.) Во втором эксперименте практически сразу была открыта и ψ' -частица с массой 3,685 ГэВ. Несколько позже в экспериментах на астречных электрон-позитронных лучках были обнаружены и др. П.-ч. Их совр. характеристики приведены в табл.

Открытие J/ψ -частицы исторически сыграло очень важную роль в становлении кварковой теории строения адронов. J/ψ была первым изученным тяжёлым мезоном, имеющим удивительно малую распадную ширину (всего 63 кэВ при типичных ширинах для

мезонов такой массы ≈ 200 МэВ; см. *Время жизни*).
 Еднство: последоват. объяснение этому парадоксу можно было дать на основе предположения, что J/ψ является связанным состоянием ещё не известных к тому моменту тяжёлых кварка и антикварка, несущих новое квантовое число, названное очарованием. Быстрый распад такой системы из очарованных кварка и антикварка возможен только на два мезона, каждый из к-рых имеет в своём составе, по крайней мере, один очарованный кварк (с-кварк) или один антикварк. Существование таких мезонов, названных D-мезонами, сначала было постулировано, а в 1976 они были обнаружены (см. *Очарованные частицы*). Масса D-мезона оказалась равной 1864 МэВ. В силу того, что суммарная масса двух D-мезонов ($2m_D = 3728$ МэВ) превышает массу J/ψ и ψ' -частиц, их распад на пару $D + \bar{D}$ невозможен (что и было исходно предположено). Распады же на др. мезоны идут с заметно меньшей вероятностью. Это объясняет малые ширины J/ψ и ψ' -частиц и существование больших (десятки МэВ) ширины других П.-ч.

Эксперим. открытие D-мезонов — носителей нового квантового числа — явилось убедит. доводом в пользу правильности трактовки физ. природы П.-ч. и решающим образом подтвердило всю концепцию кваркового строения адронов.

Т. о., по совр. представлениям, П.-ч. — связанные системы из с-кварка и анти-с-кварка: $\psi = (c\bar{c})$ (см. *Кварковые*). J/ψ -частица — наименее возможное состояние этой системы при параллельных спинах и $L = 0$. ψ' — первое радиальное возбуждение этой системы. Следующие П.-ч. являются либо орбитальными ($L = 2$), либо радиальными возбуждениями осн. состояния с ещё большим главным квантовым числом (табл.).

Лит.: 1) А. Берт и др., Experimental observation of heavy particle J/ψ , Phys. Rev. Lett., 1974, т. 33, р. 1404; 2) А. Глэшоу и др., Discovery of a narrow resonance in e^+e^- annihilation, там же, р. 1406; 3) Глэшоу Ш., Кварки с цветом и ароматом, пер. с англ., «ВФН», 1976, т. 119, в. 4, с. 715.

А. А. Кожар.

ПУАЗ (П, P) — единица динамики вязкости в СГС системе единиц. Назв. в честь Ж. Л. Пуазейля (J. L. Poiseuille). $1 \text{ П} = 0,1 \text{ Па} \cdot \text{с}$.

ПУАЗЕЙЛЯ ЗАКОН (Хагена — Пуазейля закон) — закон установившегося течения вязкой несжимаемой жидкости в тонкой цилиндрич. трубке круглого сечения. Сформулирован впервые Ж. Хагеном (G. Hagen) в 1839 а вскоре повторно выведен Ж. Л. Пуазейлем (J. L. Poiseuille) в 1840—41. Согласно П. з., секундный объёмный расход жидкости пропорционален перепаду давления на единицу длины трубки:

$$Q = k \frac{p - p_0}{l} d^4 = \frac{\pi}{128} \frac{p - p_0}{\mu} d^4,$$

где Q — объём жидкости, протекающей за 1 с через сечение трубки, p и p_0 — давление в двух сечениях трубки, d — диаметр трубки, l — расстояние между сечениями, μ — коэф. вязкости. Связь коэф. k с коэф. вязкости μ установлена в 1845 Дж. Стоксом (G. Stokes): $k = \mu/128\pi$.

П. з. применим только при ламинарном течении жидкости и при условии, что длина трубки превышает т. н. длину вач. участка, необходимого для развития ламинарного течения в трубке. Течение, подчиняющееся П. з., наз. течением Пуазейля; оно характеризуется параболич. распределением скорости по радиусу трубки R : $u = u_{\text{макс}} (1 - r^2/R^2)$, где u — скорость на расстоя-

нии r от оси, $u_{\text{макс}}$ — скорость на оси трубки. В ламинарном течении, подчиняющемся П. з., в каждом поперечном сечении трубки ср. скорость $u = Q/\pi R^2$ вдвое меньше макс. скорости $u_{\text{макс}}$ в этом сечении. П. з. применяется для определения коэф. вязкости разл. жидкостей при разл. темп-рах посредством капиллярных вискозиметров. С. М. Висескицкий.

ПУАЗЕЙЛЯ ТЕЧЕНИЕ — ламинарное течение жидкости через тонкие цилиндрич. трубки. Описывается Пуазейля законом.

ПУАНКАРЕ ГРУППА (неоднородная группа Лоренца) — группа всех вещественных преобразований 4-векторов $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ пространства Минковского M_4 вида $x'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta x^\beta + a^\alpha$, где Λ — преобразование из Лоренца группы, а a^α — 4-вектор смещения (трансляции). Элемент П. г. обычно обозначается $\{a, \Lambda\}$, а закон композиции имеет вид $\{a_1, \Lambda_1\} \{a_2, \Lambda_2\} = \{a_1 + \Lambda_{a_2}, \Lambda_1 \Lambda_2\}$. П. г. играет чрезвычайно важную роль в релятивистской физике, являясь группой её глобальной симметрии. Она была введена в 1905 А. Пуанкаре (H. Poincaré). Как и группа Лоренца, П. г. имеет четыре компонента связности, различные значениями $\det \Lambda$ и знаком Λ^0_0 , а именно: \mathcal{S}^\pm , \mathcal{S}^\perp , \mathcal{S}^\perp и \mathcal{S}^\perp . Это — небелева, некомпактная группа Ли. Навб.ковой является компонента \mathcal{S}^\perp , представляющая собой множество преобразований $\{a, \Lambda\}$ с $\Lambda \in L^\perp$, содержащая единичное преобразование. В дальнейшем речь будет идти именно об этой группе.

Группа \mathcal{S}^\perp — 10-параметрическая; к шести генераторам $M_{\alpha\beta}$ группы Лоренца добавляются четыре генератора P_α трансляций. Ли алгебра П. г. определяется переставочными соотношениями для генераторов:

$$[M_{\mu\nu}, M_{\alpha\beta}] = i(\delta_{\mu\alpha} M_{\nu\beta} - \delta_{\nu\alpha} M_{\mu\beta} - \delta_{\mu\beta} M_{\nu\alpha} + \delta_{\nu\beta} M_{\mu\alpha}),$$

$$[P_\alpha, P_\beta] = 0, [M_{\mu\nu}, P_\alpha] = i(\delta_{\mu\alpha} P_\nu - \delta_{\nu\alpha} P_\mu),$$

где $\delta_{\alpha\beta}$ — метрич. тензор. 10 генераторов П. г. являются осн. динамич. величинами в релятивистской механике. Величину P_α наз. вектором энергии-импульса или 4-импульсом; 3-вектор $\mathbf{M} = (M_{23}, M_{31}, M_{12})$ есть угл. момент. В квантовой теории поля для любого оператора $A(x)$

$$[A(x), P_\mu] = i\partial A(x)/\partial x^\mu.$$

В частности, эволюция во времени определяется оператором P_0 , или гамильтонианом системы.

Для П. г. имеется два Кэшира оператора, коммутирующих со всеми её генераторами и, следовательно, релятивистски инвариантных. Это $P^2 = P_\alpha P^\alpha$ и $W = \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} P_\alpha M_{\beta\gamma}$, где $\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ — тензор Леви-Чивиты, а $\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = \pm 1$ — полностью антисимметричный тензор.

При $P^2 \neq 0$ имеется ещё одна дискретная инвариантная характеристика — знак энергии: $\epsilon = P_0/|P_0|$ с соств. значениями ± 1 .

Как и в случае группы Лоренца, представление П. г. строят с помощью односвязной группы \mathcal{S}_0 — универсальной накрывающей для группы \mathcal{S}^\perp (см. Группа). Для квантовой теории поля важны унитарные неприводимые представления \mathcal{S}^\perp (см. Представление группы). Согласно требованию релятивистской инвариантности, векторам состояния отвечают т. н. проективные представления, задаваемые с точностью до фазового множителя. Имеет место теорема Вигнера — Баргмана, утверждающая, что любое проективное представление группы \mathcal{S}^\perp порождается обычным однозначным унитарным представлением группы \mathcal{S}_0 .

Изучение важных для физики унитарных представлений группы \mathcal{S}_0 сводится к классификации её неприводимых унитарных представлений, т. к. хотя \mathcal{S}_0 и некомпактна, любое её унитарное представление может

быть разложено в прямую сумму (или интеграл) неприводимых представлений.

Группа \mathcal{S}_0 локально изоморфна группе \mathcal{S}_1^+ и имеет те же генераторы и те же операторы Каазимира, что и \mathcal{S}_1^+ . В зависимости от значений оператора P^3 представления группы \mathcal{S}_0 могут быть разделены на следующие классы:

- 1) $P^3 = m^2 > 0$.
4) $\epsilon = 1$ (т. е. $P_0 > 0$). Соответствующие представления описывают трансформ. свойства реальных частиц с массой покоя m .
- 16) $\epsilon = -1$ (т. е. $P_0 < 0$). Эти представления комплексно сопряжены с представлениями класса 1а.
- 2) $P^3 = 0, P \neq 0$.
2а) $\epsilon = 1$ ($P_0 > 0$). Соответствующие представления описывают частицы с нулевой массой покоя (нейтрино и фотон).
- 2б) $\epsilon = -1$ ($P_0 < 0$). Представления этого класса комплексно сопряжены с представлениями класса 2а.
- 3) $P^3 = -m^2 < 0$ (т. е. вектор P пространственно подобен). Согласно осн. принципам релятивистской механики, частицы с таким импульсом не могут реально существовать. Однако представления класса 3 также встречаются в квантовой теории поля, напр. при описании трансформ. свойств взаимодействующих полей.
- 4) $P = 0$. Все состояния с таким P трансляционно инвариантны. Все унитарные представления этого класса, кроме единичного, бесконечномерны. Единичное представление соответствует вакууму, инвариантно относительно всех преобразований из П. г.

Физ. смысл инварианта m^2 выявляется просто при $m^2 > 0, P_0 > 0$. В этом случае величина $-m^2/m^2$ равна квадрату угл. момента M^2 в состоянии покоя, т. е. квадрату спина.

Т. о., неприводимое унитарное представление П. г. характеризуется значениями массы m , спина S и знака энергии (при $m^2 > 0$).

Лит.: Боголюбов Н. Н., Логунов А. А., Тодоров И. Т., Основы алгебраического подхода в квантовой теории поля, М., 1989; Новиков Ю. В., Введенко в теории элементарных частиц, М., 1972; Мишель Л., Шаф Ф. М., Симметрия в квантовой физике, пер. с англ., М., 1974; Барут А., Ротман Р., Теория представлений групп и ее приложения, пер. с англ., т. 1—2, М., 1980; Эддингтон Дж., Дюбер П., Симметрия в физике, пер. с англ., т. 1—2, М., 1983. С. И. Азаков.

ПУАНКАРЕ ТЕОРЕМА о возвращении — одна из осн. теорем, характеризующих поведение динамической системы с инвариантной мерой. Примером такой системы является гамильтонова система, эволюция x -рой описывается решениями Гамильтонова уравнений $\dot{q}_i = \partial H / \partial p_i, \dot{p}_i = -\partial H / \partial q_i$ (q_i и p_i — канонич. координаты и импульсы; $i = 1, \dots, n$; $H = H(p, q)$ — Гамильтона функция; точкой обозначено дифференцирование по времени t). Инвариантной (сохраняющейся при эволюции) мерой служит объем $\int_{A=1}^n dp_1 dq_1 \dots dp_n dq_n$ области

A в фазовом пространстве M , сохраняющийся в соответствии с Ливуилла теоремой. Согласно П. т., через любую окрестность U любой точки $x = (p_i, q_i)$, принадлежащей инвариантному множеству конечной положительной меры μ в M , проходит траектория, x -рая возвращается в U . П. т. доказана А. Пуанкаре в 1890.

Общая динамич. система описывается однопараметрич. группой отображений f^t фазового пространства на себя: для точки x из M $f^t(x) = x(t)$, причём $f^{t+s}(x) = f^s(f^t(x))$, $f^0(x) = x$. В общем случае M — некое пространство с мерой μ , инвариантность x -рой означает, что $\mu(f^t(A)) = \mu(A)$ для любой области A из M . Напр., если $f^t(x)$ — решение системы дифференц. ур-ий $\dot{x} = X(x)$ с нач. условием $f^0(x) = x_0$, то инва-

риантная мера $\mu(A) = \int_A \rho(x) dx$, где $\rho(x)$ — неотриц.

решение Ливуилла уравнения $\text{div}(\rho(x)X(x)) = 0$. Если функция Гамильтона H не зависит от времени явно, она сохраняется, а траектории не покидают поверхность уровня $M_c: H(p, q) = c$ в M . При $\text{grad} H \neq 0$ на M_c инвариантная мера на поверхности уровня задается соотношением $d\mu = d\sigma / |\text{grad} H|$, где $d\sigma$ — элемент объёма на M_c .

В общем случае П. т. утверждает, что у динамич. системы с конечной инвариантной мерой для почти всех точек $x \in A$ при $\mu(A) > 0$ траектория $f^t(x)$ возвращается в A : найдётся такое $t > 1$, что $f^t(x) \in A$. При некоторых предположениях относительно M П. т. усиливается: траектории возвращаются в A бесконечное число раз, т. е. устойчивы по Пуассону.

Примеры в гамильтоновой системе ур-ий $\dot{x} = y, \dot{y} = x - x^3$ все траектории, кроме траекторий, лежащих на уровне $H = 0, H = (y^2 - x^2 + x^4)/2$, являются периодическими, поэтому возвращаются в любую свою окрестность. Отображение f тора T^2 с координатами $(\varphi, \psi) \pmod{2\pi}$, задаваемое соотношением $(\varphi, \psi) \rightarrow (2\varphi + \psi, \varphi + \psi)$, сохраняет площадь. Здесь периодических точек счётное множество, а через множество полной меры проходит траектория, не являющаяся периодической, но устойчивая по Пуассону. Пусть F — любая непрерывная функция на фазовом пространстве M динамич. системы f^t , удовлетворяющей условиям П. т. Тогда для почти всякой точки $x \in M$ и любого, сколь угодно малого $\epsilon > 0$ найдётся последовательность значений $t_n \rightarrow \infty$, для x -рой $|F(x) - F(f^{t_n}(x))| < \epsilon$, т. е. значение $F(x)$ при движении вдоль траектории повторяется с любой заданной точностью. На это утверждение опирается известный парадокс классич. статистич. механики (парадокс возврата Пуанкаре — Чермелло), однако, строго говоря, ни одна из используемых для построения этого парадокса функций (австропия и т. д.) не является функцией на фазовом пространстве.

Лит.: Немыцкий В. В., Степанов В. В., Качественная теория дифференциальных уравнений, 2 изд., М. — Л., 1948; Арнольд В. И., Математические методы классической механики, 2 изд., М., 1979; Л. М. Лерван, Явление выхода в возвращение точек области A в заданное с определ. точностью микроскопич. состояние — признак неэргодичного процесса, чтобы его можно было оценить одним характерным временем, называемым временем возвращения Пуанкаре. Ср. время возвращения (цикл Пуанкаре)

$$Q^* = \tau / \mu(A),$$

где τ — промежуток между измерениями; инвариантная мера $\mu(A) = \int |\text{grad} H(p, q)|^{-1} d\sigma$, где интегрирование проводится по изоэнергетич. поверхности $H(p, q) = \text{const}$.

П. т. не даёт конструктивного построения самого возвращения и нуждается в его реализации с помощью некоего случайного процесса. Ср. время возвращения удалось оценить М. Смолуховскому (М. Smoluchowski, 1915) с помощью случайного процесса, моделирующего броуновское движение. Он показал, что цикл Пуанкаре значительно больше вероятного времени возвращения наблюдаемого макроскопич. состояния в исходное равновесное состояние.

П. т. рассматривает динамич. системы со строго фиксиров. энергией E . В статистич. физике им соответствуют системы, описываемые микроканонич. распределением Гиббса (см. Гиббса распределение). Энергия этих систем задана с точностью $\Delta \epsilon \ll \epsilon$ ($\Delta \epsilon$ можно принять равной ср. флуктуации энергии). Число состояний, находящихся в слое $\Delta \epsilon$ (определяемое статистич. весом $M(\epsilon, V, N)$, где N — число частиц, V — объём), чрезвычайно велико. Аналогичное рассмотрение возможно и для др. ансамблей Гиббса.

Реальное время возвращения системы из неравновесного состояния к статич. равновесию может быть оценено на основании Онсагера гипотезы, предполагаю-

щей, что затухание больших флуктуаций происходит по законам термодинамики неравновесных процессов. Хотя большие флуктуации очень редки, все следствия гипотезы Онегера хорошо подтверждаются экспериментально и позволяют установить связь между *квантовыми коэффициентами* и равновесными флуктуациями потоков (см. Грина — Кубо формулы).

Лит.: Смолаховский М. Молекулярно-теоретические исследования по вопросу об обращении термодинамически необратимых процессов и о возврате аномальных состояний, в сб.: Эйнштейн А., Смолуховский И. М., Броуновское движение, пер. с нем., М., 1936, с. 273; Квант. М., Вероятность и смежные вопросы в физике, пер. с англ., М., 1965.

Д. Н. Зубарев.

ПУАССОНА КОЭФФИЦИЕНТ — см. Модули упрямости.

ПУАССОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — распределение случайной величины X , принимающей целые неотрицательные значения r :

$$P(X=r) = \frac{\mu^r \exp(-\mu)}{r!},$$

где $\mu > 0$ — параметр. Ср. значение $M(X) = \mu$, дисперсия $D(X) = \mu$, производящая функция $G(z) = \exp\{\mu(z-1)\}$. П. р. определяет вероятность наблюдения r событий в данный интервал времени t , если эти события независимы и возникают с пост. скоростью ν ($\mu = \nu t$). П. р. подчиняется, напр., числу радиоакт. распадов x в течение заданного времени t :

$$P(x=r) = (\nu t)^r \exp(-\nu t) / r!,$$

где ν — ср. скорость распадов. При $\mu \rightarrow \infty$ П. р. приближается к Гаусса распределению.

Лит.: Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 3 изд., М., 1987. В. П. Жигунов.

ПУАССОНА СКОБКИ — важное понятие аналитической механики, введенное С. Пуассоном (S. Poisson) в 1809 и получившее дальнейшее развитие в гамильтоновой механике (см. Гамильтоновы формулы). П. с. могут быть обобщены на случай квантовой механики, а также величин f и g нек-рой гамильтоновой системы называются выражение

$$\{f, g\} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} - \frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} \right), \quad (1)$$

где $f(q, p, t)$ и $g(q, p, t)$ — нек-рые ф-ции т. н. гамильтоновых (канонических) переменных q_1, \dots, p_n (n — число степеней свободы системы). Встречается определителем (-1) . Для обозначения П. с. могут использоваться также круглые (f, g) или квадратные $[f, g]$ скобки. Иногда термин употребляется в единств. числе — скобка Пуассона. Из определения (1) следуют свойства П. с.:

$$\{g, f\} = -\{f, g\} \quad (I);$$

$$\{\alpha f + \beta g, h\} = \alpha \{f, h\} + \beta \{g, h\} \quad (II)$$

(где α, β — нек-рые константы);

$$\{fg, h\} = \{f, h\}g + f\{g, h\} \quad (III);$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \{f, g\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} \right\} \quad (IV);$$

$$\{f, \{g, h\}\} + \{h, \{f, g\}\} + \{g, \{h, f\}\} = 0 \quad (V)$$

(тождество В. — т. е. тождество Якоби). Важным свойством П. с. является их инвариантность относительно канонич. преобразований (инвариантность относительно перехода к др. набору канонич. переменных Q_1, \dots, P_n):

$$\{f, g\} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial P_k} \frac{\partial g}{\partial Q_k} - \frac{\partial f}{\partial Q_k} \frac{\partial g}{\partial P_k} \right), \quad (1^*)$$

причем оба набора переменных удовлетворяют Гамильтона уравнениям. Если одна из ф-ций f или g совпадает с обобщенной координатой q_i или обобщенным импульсом p_k , то

$$\{f, q_i\} = \frac{\partial f}{\partial p_i}; \quad \{p_k, g\} = \frac{\partial g}{\partial q_k}. \quad (2)$$

Если и вторая ф-ция заменена на координату или импульс, то

$$\{q_i, q_k\} = 0; \quad \{p_i, p_k\} = 0; \quad \{p_i, q_k\} = \delta_{ik}. \quad (3)$$

Выполнение условия (3) для к.-л. набора переменных q_1, \dots, p_n есть критерий каноничности этого набора. Замена f на гамильтоновы системы H , а g — на q_i или p_k даёт

$$\{H, q_i\} = -\dot{q}_i; \quad \{H, p_k\} = \dot{p}_k, \quad (4)$$

т. е. соотношения, совпадающие с ур-ниями Гамильтона. Однако наиб. полно проявляется важность понятия П. с. при рассмотрении полной производной по времени от нек-рой величины. величина $F(q, p, t)$:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \{H, F\}. \quad (5)$$

При выводе (5) использованы ур-ния Гамильтона и определение П. с. (1). Для сохраняющейся со временем величины F (т. е. интеграла движения) имеет место равенство

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \{H, F\} = 0, \quad (6)$$

принимавшее в случае F , не зависящего явно от времени, вид

$$\{H, F\} = 0. \quad (7)$$

Из (5), (6) и свойств П. с. вытекает Пуассона теорема — П. с. двух интегралов движения F и G есть также интеграл движения:

$$\frac{d}{dt} \{F, G\} = 0. \quad (8)$$

В квантовой механике, в к-рой роль классич. динамич. величин играют эрмитовские операторы, аналог (1) являются т. н. квантовые П. с.

$$\{\hat{f}, \hat{g}\}_{\text{кв}} = \frac{i}{\hbar} [\hat{f}, \hat{g}] \equiv \frac{i}{\hbar} (\hat{f}\hat{g} - \hat{g}\hat{f}). \quad (9)$$

[Определение этих скобок иногда также отличается от (9) множителем $(-i)$.] Квантовые П. с. обладают теми же свойствами $(I - V)$, что и классические, причем доказательство справедливости тождества Якоби является в квантовом случае более простым. Сохраняют свой вид соотношения (3), и тем самым коммутат. соотношение Борна — Йордана

$$[\hat{p}_x, \hat{x}] = -i\hbar$$

представляет собой аналог соответствующей классич. ф-лы, что впервые использовано П. Дираком (P. Dirac) в построении формального матем. аппарата квантовой механики. Через квантовые П. с. выражается оператор, отвечающий производной по времени нек-рой физ. величин A :

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} + \{H, \hat{A}\}_{\text{кв}} \equiv \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} + \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{A}]. \quad (10)$$

Наконец, сохраняет свой вид теорема Пуассона: умноженный на i/\hbar коммутатор двух интегралов движения есть также интеграл движения. В квантовом случае теореме Пуассона может быть придана групповая интерпретация, если интегралы движения обусловлены той

як иной группой симметрии задачи (посредством *Нтеор* теоремы). В таком случае интегралы движения совпадают (с точностью до множителя) с генераторами группы симметрии квантовой системы $\hat{\Lambda}_\alpha$. Коммутатор к.-л. пары генераторов (являющийся в силу теоремы Пуассона интегралом движения) должен к.-л. образом выражаться через все эти генераторы. Обычно эта связь линейна:

$$[\hat{\Lambda}_\alpha, \hat{\Lambda}_\beta] = iC_{\alpha\beta}^{\gamma} \hat{\Lambda}_\gamma, \quad (11)$$

(по индексу γ подразумевается суммирование). Ф-лы (11) фактически совпадают с соотношениями, определяющими Ли алгебру соответствующей группы симметрии квантовой системы, где $C_{\alpha\beta}^{\gamma}$ — т. в. с т р у к т у р н ы е к о н с т а н т ы. Следует иметь в виду, что в ф-м. лит-ре генераторы, как правило, являются эрмитовскими операторами, тогда как в матем. лит-ре — антиэрмитовскими. По этой причине в правой части соотношения (11) возникает мнимая единица i , и возможно появление множителя (-1) .

В ряде случаев складывается, в известном смысле, обратная ситуация, если не все из имеющихся в данной задаче интегралов движения связаны с иной (следующей на геом. соображений) группой симметрии. Если коммутатор любой пары интегралов движения линейно выражается через все интегралы движения

$$[\hat{M}_\alpha, \hat{M}_\beta] = iD_{\alpha\beta}^{\gamma} \hat{M}_\gamma, \quad (12)$$

можно попытаться найти группу, алгебра Ли которой описывается соотношениями (12). Если такая группа существует, то о ней говорят как о группе «скрытой» симметрии задачи (при этом числа $D_{\alpha\beta}^{\gamma}$ являются структурными константами этой группы). Следующие примеры иллюстрируют изложенное.

1. Свободная частица массы m с импульсом p : $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$. Группа симметрии — группа движений трёхмерного пространства (совокупность трёхмерных вращений и произвольных трансляций). Имеющиеся в данной задаче интегралы движения — компоненты импульса \hat{p} и момента импульса $\hat{L} = [r, \hat{p}]$, действующие на \hat{L} представляют собой набор генераторов упомянутой группы.

2. Частица в трёхмерном центр. поле: $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + U(r)$. Группа симметрии задачи — группа трёхмерных вращений $O(3)$. Компоненты момента импульса \hat{L} (в единицах \hbar) являются генераторами группы $O(3)$.

3. Трёхмерный изотропный осциллятор: $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + m\omega^2 r^2/2$. Явная (геометрическая) симметрия задачи — $O(3)$. Кроме момента импульса \hat{L} имеется ещё три очевидных интеграла движения

$$\hat{H}k = \frac{\hat{p}_k^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x_k^2}{2},$$

$k = 1, 2, 3$ — сохраняющиеся энергии трёх независимых осцилляторов, отвечающих колебаниям вдоль трёх декартовых осей. Они взаимно перестановочны. Коммутаторы вида $[\hat{H}k, \hat{L}_l]$ порождают интегралы движения

$$K_l = \frac{p_l p_r}{m} + m\omega^2 x_l x_r$$

и т. п. Удобно перейти к следующим операторам:

$$\hat{\lambda}_k^+ = \hat{a}_k^+ + \hat{a}_k^-, \quad \hat{a}_k^+ = \frac{m\omega\hat{x}_k + i\hat{p}_k}{\sqrt{2m\hbar\omega}}, \quad \hat{a}_k^- = \frac{m\omega\hat{x}_k - i\hat{p}_k}{\sqrt{2m\hbar\omega}},$$

через к-рые исходные интегралы движения выражаются в виде линейных комбинаций

$$\hat{H}_1 = \hbar\omega \left(\hat{A}_1^+ + \frac{1}{2} \right), \dots,$$

$$\hat{K}_l = \hbar\omega \left(\hat{A}_3^+ + \hat{A}_2^+ \right), \quad \hat{L}_l = i\hbar \left(\hat{A}_2^+ - \hat{A}_3^+ \right)$$

и т. п.

Алгебра Ли, связанная с операторами \hat{A}_i^{\pm} , описывается соотношениями

$$[\hat{A}_i^j, \hat{A}_k^l] = \delta_i^l \hat{A}_k^j - \delta_k^j \hat{A}_i^l,$$

представляющими собой канонич. форму алгебры Ли группы трёхмерных унитарных преобразований $U(3)$ — группы «скрытой» симметрии трёхмерного изотропного осциллятора. Отсутствие множителя i в правой части предыдущего соотношения обусловлено неэрмитовостью (вообще говоря) инфинитезимальных операторов \hat{A}_i^{\pm} .

4. Атом водорода. В атомных единицах ($e = \hbar = m = 1$) гамильтониан задачи имеет вид $\hat{H} = \hat{p}^2/2 - 1/r$. Кроме момента импульса \hat{L} (безразмерного в используемых единицах) задача обладает специфич. векторным интегралом движения, т. н. вектором Рунге — Леша:

$$\hat{A} = \frac{r}{r} + \frac{1}{2} [\hat{L}, \hat{p}] - \frac{1}{2} [\hat{p}, \hat{L}].$$

Удобно ввести «нормированный» вектор Рунге — Леша, имея в виду отрицательность энергии в связанных состояниях атома водорода:

$$\hat{N} = \frac{1}{V - 2\hat{H}} \hat{A}.$$

Коммутац. соотношения между операторами \hat{L}_α и \hat{N}_β имеют вид

$$[\hat{L}_\alpha, \hat{L}_\beta] = i\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{L}_\gamma; \quad [\hat{L}_\alpha, \hat{N}_\beta] = i\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{N}_\gamma;$$

$$[\hat{N}_\alpha, \hat{N}_\beta] = i\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{L}_\gamma;$$

$\epsilon_{\alpha\beta\gamma}$ — полностью антисимметричный единичный псевдотензор в пространстве трёх измерений. Последние соотношения представляют собой алгебру Ли группы вращений четырёхмерного евклидова пространства $O(4)$ — группу «скрытой» симметрии атома водорода.

Аналог П. с. может быть получен в классич. теории поля, если описание этого поля допускает применение гамильтонова формализма. Для двух динамич. величин F и G , характеризующих поле как целое, т. е. являющихся интегральными характеристиками поля и тем самым функционалами гамильтоновых переменных $\xi(r, t)$ и $\pi(r, t)$ (играющих роль обобщённых координат и импульсов гамильтоновой системы с конечным числом степеней свободы), П. с. определяются соотношением

$$\{F, G\} \text{ на поле} = \iiint_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\delta F}{\delta \pi} \frac{\delta G}{\delta \xi} - \frac{\delta F}{\delta \xi} \frac{\delta G}{\delta \pi} \right) d^3r, \quad (13)$$

где $\delta/\delta\pi$, $\delta/\delta\xi$ — т. н. функциональные производные, имеющие в простейшем случае скалярного поля (и лагранжиана 1-го порядка) вид

$$\frac{\delta F}{\delta \pi} = \frac{\delta F}{\delta \pi}; \quad \frac{\delta G}{\delta \xi} = \frac{\delta G}{\delta \xi} - \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\delta G}{\delta \partial \xi} \right),$$

f и g — плотности величин F и G :

$$F = \iiint f(\xi(r, t), \pi(r, t), t) d^3r,$$

G — определяется аналогичным образом.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; и х же, Механика, 4 изд., М., 1988; Шифф Л., Квантовая механика, пер. с англ., 2 изд., М., 1989; Г в я т м х е р Ф. Р., Лекции по аналитической механике, 2 изд., М., 1986; Л а н ц о ш К., Вариационные принципы механики, пер. с англ., М., 1985; Х а а р Д. т е р, Основы гамильтоновой механики, пер. с англ., М., 1974; Д ж е м м е р М., Эволюция понятий квантовой механики, пер. с англ., М., 1985. С. П. Палеев.

ПУАССОНА УРАВНЕНИЕ — неоднородное дифференциальное уравнение в частных производных

$$\Delta u(x) = -f(x),$$

где Δ — Лапласа оператор, $x = (x_1, \dots, x_n)$. Краевые задачи для П. у. сводятся к соответствующим задачам Лапласа уравнения подстановкой

$$u = v + V,$$

где v удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta v = 0$, а V — функции, решение П. у. в области G :

$$V(x) = (2\pi)^{-n} \int_G d\mu \ln |x - y|^{-n} / |y|, \quad n \geq 2$$

(логарифмич. потенциал);

$$V(x) = -\frac{1}{(n-2)\pi_n} \int_G d\mu |x - y|^{2-n} / |y|, \quad n \geq 3$$

(ньютонов потенциал). Здесь $\pi_n = 2\pi^{n/2} \Gamma(n/2)$ — площадь поверхности единичной сферы в n -мерном евклидовом пространстве, Γ — гамма-функция (см. Эйлеры интегралы).

П. у. фигурирует в обширном круге физ. задач. Ему удовлетворяют: потенциалы ньютоновых (кулоновых) сил, порожденных массами (зарядами), распределенными в области G с плотностью $\rho(x) = f(x)/4\pi$; потенциал скорости идеальной несжимаемой жидкости; характеристики стационарных процессов теплопроводности и диффузии. П. у. возникает также в стационарных задачах теории упругости.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 4 изд., М., 1988; и х же, Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; и х же, Теория упругости, 4 изд., М., 1987; Трихонов А. Н., Сажинский В. А., А. А., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1977; Владимиров В. С., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1988. В. П. Палеев.

ПУАССОНА ФОРМУЛА — формула, представляющая единство, классиф. решение $\mu(x, t)$ Коши задачи для волнового уравнения

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mu}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \mu}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \mu}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} f(x, t),$$

$$\mu(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial \mu(x, t)}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

в трёхмерном пространстве-времени,

$$\begin{aligned} \mu(x, t) = & \frac{1}{2\pi c} \int_{|y-x|^2 \leq c^2 t^2} \frac{\pi(y) dy}{(c^2 t^2 - |y-x|^2)^{1/2}} + \\ & + \frac{1}{2\pi c} \int_{|y-x|^2 < c^2 t^2} \frac{\varphi(y) dy}{(c^2 t^2 - |y-x|^2)^{1/2}} + \\ & + \frac{1}{2\pi c} \int_0^t d\tau \int_{|(c t - \tau)^2 - |y-x|^2|^{1/2}} f(y, \tau) dy \end{aligned}$$

где $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y \in R^3$; c — скорость распространения сигнала; в случае, если начальные данные $\varphi(x)$, $\psi(x)$ — соответственно трижды и дважды непрерывно дифференцируемые ф-ции, а $f(x, t)$ — дважды непрерывно дифференцируемая ф-ция.

Лит.: Владимиров В. С., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1988. В. П. Палеев.

ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА — прибор для регистрации следов (треков) заряд. частиц, действие к-рого основано на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории частицы.

Историческая справка. Д. А. Глейзер (D. A. Glaser) в 1952 в поисках трекового детектора заряд. частиц, более эффективного, чем применявшиеся в то время (ядерные фотографические эмульсии, Вильсона камера и диффузионная камера), обратил внимание на работы К. Я. Висмара и др. (1922—24). Дистилловый эфир (в нормальных условиях кипящий при темп-ре $T = 34,6^\circ\text{C}$, нагретый под давлением 20 атм до $+130^\circ\text{C}$, расширился до 1 атм. При этом он не кипел часами. После доведения темп-ры до 140°C он закипал через произвольные промежутки времени. Глейзер установил, что частота закипания соответствует частоте прохождения космич. частиц на уровне моря. Он повторил эксперимент, расположив над и под колбой с эфиром счётчики Гейгера. Вскипания было мгновенным в присутствии радиоакт. источника. Скоростная киносъёмка установила, что закипание начинается вдоль траектории заряд. частицы.

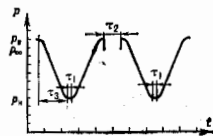
Первая П. к. (1954) представляла собой металлич. камеру со стеклянными окнами для освещения и фотографирования, заполненную жидким водородом. В дальнейшем П. к. создавались и совершенствовались во всех лабораториях мира, оснащённых ускорителями заряд. частиц. Начиная от колбочки объёмом в 3 см³, размер П. к. достиг неск. м³, напр. камера СКАТ (ИФВЭ, СССР) 8 м³, «Мирабель» (Франция — СССР) 12 м³, большая Европейская П. к. (ЦЕРН) более 30 м³, П. к. FNAL (Батавия, США) св. 40 м³. Большинство П. к. имеют объём ~ 1 м³. (За изобретение П. к. Глейзеру в 1960 присуждена Нобелевская премия.)

Образование пузырьков. Быстрая заряд. частица выбивает на своём пути в веществе электроны разных энергий (σ -электроны). Электроны достаточно больших энергий, удаляясь от траектории, в свою очередь, выбивают вторичные σ -электроны в т. д. В результате многократных столкновений с атомами жидкости σ -электроны тормозятся вблизи траектории и вызывают доплот. нагрев жидкости в области радиусом r . Это приводит к образованию центров кипения — зародышей. Образовавшийся зародыш пузырька радиусом r больше некоего критич. $r_{кр}$ будет расти за счёт испарения окружающей его жидкости во внутр. полости пузырька. Величина $r_{кр}$ определяется соотношением

$$r_{кр} = \frac{2\sigma}{(\rho_{\infty} - \rho_0)(1 - V_{кр}/V_0)}, \quad (1)$$

Здесь σ — поверхностное натяжение жидкости на границе жидкост. — пар при темп-ре T ; ρ_{∞} — равновесное давление пара над бесконечно плоской поверхностью жидкост.; ρ_0 — давление, при к-ром находится перегретая жидкост.; V_0 , $V_{кр}$ — уд. объёмы жидкост. и пара. Разность давлений, называемая перегревом жидкост., осуществляется изменением объёма на величину $\Delta V/V = (0,5-2)\%$ для разных камер. Время расширения τ_1 , т. е. время изменения давления от верх. значения p_0 , к-рое на 1,5—2 атм и более превышает p_{∞} , до p_1 , равно 5—20 мс (рис. 1).

Рис. 1. Схема рабочих циклов пузырьковой камеры: τ_1 — задержка вспышки света на рост пузырька; τ_2 — время между рабочими циклами; τ_3 — время расширения.



Экспериментально установлена зависимость числа пузырьков n на единице длины трека (плотность пузырьков) для однозарядной быстрой частоты от её скорости v : $n = A/\beta^2$, $\beta = v/c$. Число δ -электронов n_δ , выбиваемых частицей и способных создать пузырьки, равно

$$n_\delta = A \frac{Z^2}{\beta^2}; A = \frac{2\pi e^4 N Z_0 m c^2}{\mu} \quad (2)$$

Здесь e — заряд электрона, m — его масса, ρ — плотность жидкости, N — число Авогадро, Z_0 — число электронов молекулы жидкости, Z — заряд частицы, μ — мол. вес, ϕ — энергия δ -электрона, способного создать зародыш одного пузырька. Электроны больших энергий, удаляясь от траектории частицы и выбивая δ -электроны, образуют след из цепочки пузырьков (рис. 2, 3). Электроны малых энергий не создают пузырьков критич. размера; мин. энергия ϕ_c , требующаяся для создания зародка пузырька критич. размера в

В точке А
 $\vec{p} + \vec{p} \rightarrow 4\vec{p}^+ + 4\pi^-$

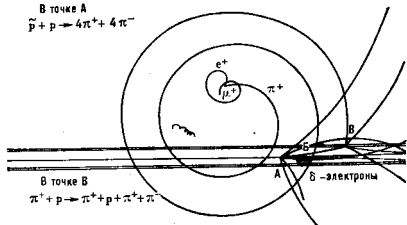


рис. 2. Фотография следов частиц, полученные на водородной камере ОИИИ «Людмила»; $H = 2,6$ Тл; облучение антинейтроном $22,4$ ГэВ/с на ускорителе ИФЭФ. В точке А происходит взаимодействие $p + p \rightarrow 4p^+ + 4\pi^-$. Быстрый π^+ взаимодействует вторично в точке В: $\pi^+ + p \rightarrow \pi^+ + p + \pi^+ + \pi^-$, по пути образуя в точке В энергичный δ -электрон; π^+ , образовавшийся в точке В, закручиваясь магн. полем в спираль, тормозится до останков и распадается по схеме $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + e^+$.

пропане, равна 390 эВ, в водороде — 165 эВ. При этом в пропане $n_\delta = 100$ см $^{-1}$, в водороде — 58 см $^{-1}$. В большинстве экспериментов получают на 1 см трека 15 пузырьков. Это означает, что $n \neq n_\delta$, т. е. что не каждый δ -электрон, способный создать зародышевый пузырек, создаёт его и что не каждый зародыш вырастает до размеров пузырька, видимого при обычном фотографировании. В процессе формирования и роста пузырьков происходит их «схлопывание» увеличивающимся из-за закипания давлением, а также слияние

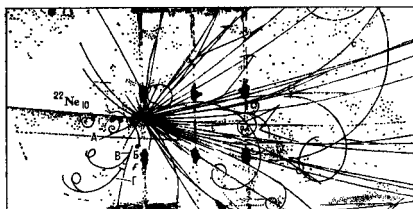


рис. 3. Фотография следов частиц, полученные на пропановой камере (ОИИИ); $H = 1,55$ Тл; облучение релятивистскими ядрами на синхрофазотроне (ОИИИ). Ядро ^{22}Ne с импульсом $32,4$ ГэВ/с в точке А взаимодействует с мишенью из Та (теплые доплерские полусферы-пластины Та), образуя св. 50 вторичных частиц. Плотные следы принадлежат останавливающимся протонам. Излучаемый γ -квант (от А до Б) в точке В конвертируется в $e^- - e^+$ -пару; в точке В излучается π -квант, давший в точке Г композитный электрон.

близлежащих пузырьков. Фотографирование прецизионной оптикой или голографич. метод регистрации (см. Голография) на ранней стадии формирования пузырьков даёт n , близкие к n_δ . Плотность пузырьков растёт с увеличением T и Δp , т. к. при этом для образования зародыша требуется меньшая энергия δ -электронов.

Рабочие жидкости. Наиб. широкое применение получили: жидкие водород, дейтерий, гелий и смесь водорода с неонем (криогенные П. к.); пропан, фреоны, ксенон и их смеси (тяжеложидкостные П. к.). Для изучения взаимодействий с протонами применяется жидкий водород (рис. 2), с нейтронами — дейтерий. Для изучения процессов, сопровождающихся образованием электронно-фотонных линий, удобны Xe, пропан и др. тяжёлые жидкости (рис. 3). Смесь водорода с Ne — также хороший детектор γ -квантов (см. Гамма-излучение). Нек-рые характеристики рабочих жидкостей даны в табл.

Характеристики жидкостей, наиболее часто используемых в пузырьковых камерах

Жидкость	$T, ^\circ\text{C}$	$P_{\text{оо}}, \text{атм}$	$\rho, \text{г/см}^3$	Радиационная длина $x_0, \text{см}$	Вероятность конверсии γ -квантов с $E_\gamma > 500$ МэВ на длине 50 см, %
H_2	-246	4,7	0,06	1047	4,6
D_2	80	21,5	0,43	108	36
C_2F_6	30	18	1,5	11,8	89
Xe	-19	26	2,3	3,5	100

Измерения импульсов и определение знака заряда быстрых частиц осуществляются по кривизне траектории в пост. магн. поле H (рис. 2, 3). Радиус кривизны R определяется соотношением

$$p = \frac{300HR}{\cos\theta} \quad (3)$$

Здесь p — импульс частицы в МэВ/с; H — магн. поле, в Тл; θ — угол между направлением импульса p и плоскостью, перпендикулярной H (угол погужения).

При движении в жидкости частица испытывает многократное кулоновское рассеяние и торможение (потери энергии на ионизацию), что искажает её траекторию (при больших энергиях, когда $\beta \rightarrow 1$, ионизаци. потери можно пренебречь). Ошибка в определении импульса из-за кулоновского рассеяния тем больше, чем меньше радиац. длина x_0 :

$$(\Delta p/p)_{\text{кул}} = \frac{5,7 \cdot 10^3}{\beta^2 N x_0} (\%); l \text{ в см.}$$

В тяжёлых жидкостях x_0 мало (табл.) п кулоновское рассеяние существенно:

$$\left(\frac{\Delta p}{p} \right) = \left[\left(\frac{\Delta p}{p} \right)_{\text{изм}}^2 + \left(\frac{\Delta p}{p} \right)_{\text{кул}}^2 \right]^{1/2} \quad (4)$$

Поэтому ксенонные П. к. работают без магн. поля (рис. 4). Потери на ионизацию и выбивание электронов уменьшают импульс, в результате след заряд. частицы скручивается в спираль (рис. 2). Импульсы малоэнергичных, останавливающихся частиц определяют по длине пробега (следы протонов на рис. 3), что даёт более высокую точность.

Особенности криогенных и тяжеложидкостных пузырьковых камер проявляются в их конструкциях и системах освещения. В криогенных П. к. расширение осуществляется норпием, к-рый находится в контакте с рабочей жидкостью. Для снижения давления от тепл. к холодной части П. к. служат шток из материала с малой теплопроводностью (неражающая сталь). В тяжеложидкостных П. к. применяются гибкие мемб-

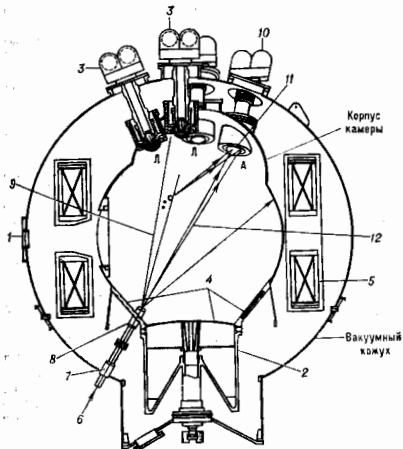


Рис. 4. Схематическое изображение криогенной пузырьковой камеры: 1 — входное окно для луча частиц; 2 — поршень расширителя; 3 — фотокамера, объективы которых окружены люминесцентными лампами; 4 — поверхность, покрытая скотчлайтом; 5 — сверхпроводящий магнет и криостат; 6 — лазерный пучок; 7 — окно вакуумного кожуха; 8 — окно в корпус камеры и расширяющая линза; 9 — освещающий корпус; 10 — голографическая фотокамера; 11 — голографическая фотопленка; 12 — опорный пучок лазера.

рваны, отделяющие жидкость от газа, с помощью к-рого производится расширение и сжатие.

Др. особенность состоит в соотношении показателей преломления жидкости и пара. У криогенных П. к. они близки. Это обуславливает узкую направленность света, рассеянного пузырьком. Фотографирование производится во встречном световом потоке. Широкие пучки света, освещающие рабочий объём П. к., сходятся в фокусе, смещённом в сторону от фотогр. объективов. Для формирования встречных пучков используются линзы, растры, толстые сферич. зеркала, зеркала с чередующимися тёмными полосами (для ташения мнимых изображений), отражат. системы из мелких стеклянных шариков («скотчлайт»).

У тяжёлых жидкостей различие в показателях преломления велико и световой пучок рассеивается на большие углы. Источник света при этом может располагаться под углом 90° к оси фотографирования.

Регистрация треков. Для стереофотографирования следов частиц в больших П. к. применяют неск. фотокамер и раал. оптич. системы, напр. объективы типа «рыбий глаз» (рис. 4). Передняя сферич. линза объектива выполняет ф-цию окна, выдерживающего давление жидкости. Вокруг объектива размещают кольцевую импульсную лампу. «Скотчлайт» наклеивается на донную часть корпуса камеры и головку поршня. После вспышки импульсной лампы свет отражается «скотчлайтом» обратно к источнику. Свет, рассеянный пузырьком, падает нормально на сферич. линзу объектива без преломления на границе жидкость — стекло. Для получения изображения пузырька, образованвшегося в ниж. части фотографируемого объёма, он должен вырасти до диаметра $\sim 0,5$ мм. У водородных камер размер пузырьков изменяется во времени: $r = 0,1Vt$ (t в мс, r в мм). Высокая скорость

роста пузырьков по сравнению со скоростью их вспышки исключает искажение треков.

Ошибки измерения пространственных координат пузырька для большинства П. к.: Δz и Δr равны 0,1 мм, $\Delta z = 0,3-1,5$ мм. П. к. с малой глубиной фотографирования и небольшим уменьшением изображения пузырькового следа позволяют фотографировать пузырьки диаметром < 100 мкм. Такие системы реализуются в быстроциклирующих П. к., используемых в гибридных установках, как мишень и детектор вершин распада короткоживущих частиц вблизи точки взаимодействия. Импульсы и др. характеристики частиц определяются магн. спектрометром (см. *Комбинированные системы детекторов*). В большой водородной П. к. FNAL ранняя стадия начала роста пузырьков осуществляется голографич. методом с помощью лазерного пучка через ≈ 1 мс после прохождения частиц. Это обеспечивает регистрацию пузырьков с $r \sim 100$ мкм. Далее, через 10 мс, когда пузырьки вырастают до диаметра $\sim 0,5$ мм, производится обычное фотографирование.

При обработке обычных фотографий с этой камеры, когда возникает потребность в обзоре области вблизи точки взаимодействия с целью поиска короткоживущих частиц, привлекается голография.

Пространственное разрешение П. к. определяется масштабом фотографирования, разрешающей способностью объективов и плёнки, откосит. отверстием объективов (при фотографировании больших глубин с малого расстояния), мощностью источника света и его монохроматичностью, стереоскопич. углом, определяемым базой (расстоянием между опич. осми фотографирования) и высотой. Требуется знание оптич. констант П. к., т. к. фотографирование производится через неск. раал. оптич. сред (стекло, жидкость, воздух). Голографич. метод регистрации позволяет получить изображение пузырьков в толстых слоях жидкости при их размерах 10 мкм. Пространственное разрешение П. к. приближается к разрешению в ядерных фотоэмульсиях.

Обработка результатов. Применение. Измерение координат точек на следах отобранных событий осуществляется с помощью микроскопов, полуавтоматич. или автоматич. измерит. устройств. По спец. программам на ЭВМ вычисляются геом. характеристики треков: углы вылета частиц, длины пробегов, импульсы, ошибки этих величин и т. д.

П. к. используются преимущественно в экспериментах на выведенных пучках заряженных и нейтральных частиц, получаемых на ускорителях. В исследованных космич. излучениях не применяются из-за отсутствия «памяти» [невозможность запуска рабочего цикла от проходящей частицы (см. *Координатные детекторы*)]. Нейтральные частицы регистрируются либо по продуктам взаимодействия с веществом в камере, либо по распадам на заряд. частицы.

Исследования, выполненные с помощью П. к., дали существ. вклад в изучение сильных и слабых взаимодействий. Были открыты антисигма-минус-гиперон (1960, Дубна), омега-минус-гиперон (1964, США), нейтральные токи (1973, ЦЕРН) и др. Обнаружены и изучены многочисл. частицы — *резонансы* и т. д.

С появлением ускорителей на всё более высокие энергии, с реализацией экспериментов на встречных пучках П. к. уступают место др. координатным детекторам. Однако небольшие быстрые П. к. (10—100 расширений в 1 с) используются в качестве мишени и детектора «вершин» событий, связанных с короткоживущими частицами. При этом информацию о характеристиках частиц получают с помощью магн. спектрометров электронными методами.

Лит.: Glaeser D. A. Some effects of ionizing radiation on the formation of bubbles in liquids. *Phys. Rev.*, 1952, v. 87, p. 665; е же ж. The bubble chamber. *Handbuch der Phys.*, 1958, Bd 45, S. 314. Злинцова Г. А., Крестникова Ю. С., Дюжиков М. Ф. Измерения возмущающей способности частиц в пузырьковой камере. *ЖЭТФ*, 1956, т. 31, с. 762; Пу-

зрьюные камеры, под ред. Н. Б. Делоне, М., 1963; Сун К., Пузырьковая камера. Измерение и обработка данных, пер. с англ., М., 1970; H a r i g e l G. G., Holography in the Fermilab, 15-foot bubble chamber, «Nucl. Instr. and Methods», 1967, т. А253, р. 814.

ПУЛЬСАРЫ — космич. радионотечники, излучение к-рых представляет собой периоды последовательности импульсов. Первые П. открыты в кон. 1967 группой радиоастрономов Кембриджского ун-та (Великобритания) под руководством Э. Хьювша (А. Hewish).

Данные наблюдений. Известно более 500 П. Периоды P следования импульсов излучения наблюдаемых П. заключены в интервале от $\approx 1,6$ мс до $\approx 4,3$ с.

Обозначение П. состоит из букв PSR (от англ. pulsar) и его экваториальных координат (см. *Координаты астрономические*) — прямого восхождения α в часах (h) и минутх (m) и склонения δ в градусах. Напр., PSR 1919 + 21 обозначает П. с координатами $\alpha = 19^h, 19^m, \delta = +21^\circ$.

Периоды П. чрезвычайно стабильны. Напр., период первого открытого PSR 1919 + 21 равен $1,337301100468 \pm 7 \cdot 10^{-13}$ с. Однако достаточно длительные наблюдения (векны и месяцы) показали, что периоды П. медленно увеличиваются со временем. Характерное время удвоения периода $\sim 10^8$ лет для самого молодого П. и $\sim 10^6$ лет для набр. старых П. Иногда у нек-рых П. наблюдаются реакне (на времена меньше суток) скачки периода. Впервые скачки периода зарегистрированы у двух самых молодых П. Относит. изменение периодов ($\Delta P/P$) составляло $\sim 3 \cdot 10^{-9}$ (PSR 0531 + 21 — П. в Крабовидной туманности) и $2 \cdot 10^{-8}$ (PSR 0833—45 — П. в созвездии Парусов). У PSR 0833—45 скачки наблюдались примерно раз в 2 года и имели $\Delta P \approx P_1 - P_2 < 0$ (т. е. периоды до и после скачка). У PSR 0531 + 21 скачки происходили в неск. раз чаще и имели как положительную, так и отрицат. величину ΔP . Впоследствии скачки периодов зарегистрированы и у старых П., причём у одного из них величина $\Delta P/P$ оказалась в ~ 100 раз больше, чем у PSR 0531 + 21.

Отд. импульсы радиоизлучения данного П. совершенно непохожи друг на друга. Однако форма усреднённого импульса, полученная усреднением неск. сотен импульсов, весьма стабильна. Для подавляющего большинства П. ширина (длительность) Δt усреднённого импульса на уровне половины макс. интенсивности заключена в интервале $(0,01—0,1)P$ и в ср. равна $0,04 P$. Однако у неск. П. величина Δt сильно отличается от ср. значения. Так, напр., излучение PSR 1544 + 09 длится почти половину его периода, у PSR 0826 — 34 — в течение всего периода. Отношение $\Delta t/P$ зависит от частоты, на к-рой ведётся наблюдение.

У ряда П. профиль усреднённого импульса резко меняется, принимая на нек-рое время другую стабильную форму, затем также резко восстанавливает свою первонач. форму. Это явление наз. сменой моды излучения П. Длительность пребывания П. в той или иной моде обычно составляет от неск. минут до неск. часов. Иногда радиоизлучение П. резко пропадает, а затем сначала возвращается к нормальному значению. Интенсивность радиоизлучения П. при таком его замкании падает более чем в 100 раз. Характерная длительность замканий от $1P$ (отсутствует лишь один импульс) до неск. десятков P .

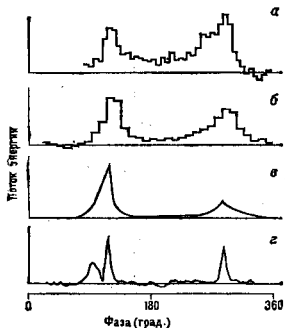
Импульсы радиоизлучения П. состоят из одного или более субимпульсов. У большинства П. субимпульсы появляются хаотически в пределах усреднённого импульса. Однако у нек-рых П. субимпульсы в последоват. импульсах систематически дрейфуют через профиль усреднённого импульса. Скорость дрейфа субимпульсов такова, что через время $\sim (2—20)P$ расположение субимпульсов периодически повторяется. Субимпульсы также имеют сложную временную структуру и состоят из отд. микроимпульсов. Так, напр., потоки радиоизлучения PSR 0950 + 08 и PSR 1133 + 16 яв-

ляются сильно переменными на временах вплоть до предела разрешения $\sim 10^{-4}$ с.

Излучение П., как правило, сильно поляризовано. Степень линейной поляризации радиоизлучения нек-рых П. (напр., PSR 0833—45) близка 100%. У ряда П. наблюдается также круговая поляризация радиоизлучения, достигающая 30—50%.

Радиоизлучение П. исследовалось в диапазоне частот от неск. десятков МГц до ~ 10 ГГц. Хотя для реал. П. спектры сильно отличаются, они обладают рядом общих свойств, а именно: на частотах ниже ~ 100 МГц и выше неск. ГГц наблюдается, как правило, сильное уменьшение плотности потока радиоизлучения, т. е. имеет место т. н. завал спектра; внутри же данного интервала частот спектр излучения степенной, со спектральным индексом от 0,6 до ≈ 3 .

От неск. П. наблюдается не только радио-, но и более высокочастотное излучение. Среди них особое место занимает молодой PSR 0531 + 21 (возраст $\sim 10^3$ лет), от к-рого зарегистрировано импульсное излучение практически во всем доступном для наблюдений диапазоне: от ДВ-радиоизлучения (частота $\nu \sim 30$ МГц) до сверхжесткого γ -излучения ($\nu \sim 10^{27}$ Гц, $h\nu \sim 10^{12}$ эВ). В этом диапазоне частот фазы максимумов импульсов излучения совпадают (рис.). Мощность излучения PSR 0531 + 21 ок. 10^{30} эрг/с в радиодиапазоне, $\sim 10^{38}$ эрг/с в оптич. диапазоне, 10^{38} эрг/с в рентг. диапазоне и 10^{44} эрг/с в γ -диапазоне. Т. о., осн. излучение



Профили усреднённых импульсов излучения PSR 0531 + 21 в гамма (а), рентгеновском (б), оптическом (с) и радиодиапазонах (д).

этого П. сосредоточено в рентг. и гамма-диапазонах, в радиодиапазоне испускается лишь ничтожная ($\sim 10^{-4}$) доля излучения. Аналогичная ситуация имеет место и для остальных П., от к-рых наблюдается ВЧ-излучение.

Оказалось, что молодые П., возраст к-рых не превосходит существенно 10^4 лет, расположены внутри остатков вспышек сверхновых (связь с остатками сверхновых надёжно установлена для восьми П.). Следовательно, все П. либо значит. часть их образуются при вспышках сверхновых звезд. Отсутствие оболочек вокруг подавляющего большинства П. связано с тем, что за время их жизни ($\sim 10^6—10^7$ лет) окружающие П. оболочки уже рассеялись.

Ок. 4% П. входят в двойные системы. В 1986 обнаружено излучение звезд, являющихся компаньонами PSR 0655 + 64 и PSR 0820 + 02. Обе звезды оказались белыми карликами. Тот факт, что один из этих белых карликов очень старый (его возраст превосходит $2 \cdot 10^8$ лет), радикально повлиял на совр. представление об

эволюции П. Ранее считалось, что П. по истечении времени $\sim 2_0$ выключаются как радиосточия $[I_0 \approx \pi(2-3) \cdot 10^8 \text{ лет} - \text{ср. возраст П.}]$. Согласно теории *теплой двойной звезд*, П. должны образоваться раньше, чем белый карлик. Следовательно, PSR 0655 + 64, входящий в двойную систему со старым белым карликом, должен иметь возраст $\geq 2 \cdot 10^8 \text{ лет}$, т. е. более чем в 100 раз больше ср. возраста П.

П. концентрируются к плоскости Галактики. Пространственная плотность П. р изменяется с расстоянием от галактик. плоскости по закону: $\rho(r) = \rho_0 \exp(-|z|/230)$. Здесь z в кп, ρ_0 — плотность П. в плоскости Галактики.

Одним из заметн. свойств П., отличающих их от остальных астр. объектов, является чрезвычайно высокая *яркостная температура* T_0 их радиоизлучения. Действительно, размер l области излучения не превышает величину $\Delta ct = 3 \cdot 10^8 - 3 \cdot 10^9 \text{ см}$ ($\Delta t = 10^{-4} - 10^{-2} \text{ с}$ — длительность импульса), т. е. меньше диаметра Земли. При радиосветимости П. $\sim 10^{28} - 10^{30} \text{ эрг/с}$ это соответствует яркостной темп-ре $10^{28} - 10^{31} \text{ К}$. У объектов, известных до открытия П., величина T_0 не превосходила $10^{15} - 10^{16} \text{ К}$. Во время коротких всплесков радиоизлучения П. их яркостная темп-ра достигает значений $10^{30} - 10^{31} \text{ К}$. Столь высокая яркостная темп-ра указывает на то, что радиоизлучение П. генерируется за счёт какого-то когерентного механизма.

Теория пульсаров. Сразу после открытия П. было высказано предположение о том, что они являются вращающимися *нейтронными звездами* с магн. полем на их поверхности $\sim 10^{12} \text{ Гс}$. Данная модель П. общепризнана. Согласно этой модели, излучение П. сильно анизотропно и испускается в малом телесном угле. При вращении нейтронной звезды наблюдатель, попадающий в диаграмму направленности излучения П., видит импульсы излучения, повторяющиеся с периодом, равным периоду вращения звезды. Высокой стабильности периода вращения нейтронной звезды и объясняется высокая стабильность периода повторения импульсов излучения П. Медленное увеличение периода П. обусловлено потерей энергии вращения нейтронной звезд:

$$L = d\mathcal{E}_{\text{кин}}/dt = -I\Omega d\Omega/dt,$$

где $\mathcal{E}_{\text{кин}} = I\Omega^2/2$ — кинетич. энергия вращения нейтронной звезды с моментом инерции I ($\sim 10^{48} \text{ г} \cdot \text{см}^2$), вращающейся с угл. скоростью $\Omega = 2\pi/P$. Эта энергия трансформируется в энергию итеплого излучения П. в следующей последовательности процессов: вращение нейтронной звезды; возникновение вследствие *униполярной индукции* сильного электрч. поля в окрестности нейтронной звезды; ускорение частиц в электрч. поле до ультрарелятивистских энергий; генерация γ -излучения при движении ультрарелятивистских частиц вдоль искривлённых магн. силовых линий (см. *Иггбное излучение*); поглощение γ -квантов в сильном магн. поле и рождение электрон-позитронных пар; развитие плазменных неустойчивостей в сильнопеременной ультрарелятивистской электрон-позитронной плазме; генерация итеплого излучения П. Концентрация микрон-позитронной плазмы вблизи поверхности П. $\sim 10^{13} - 10^{16} \text{ см}^{-3}$ и убывает при удалении от П. пропорционально напряжённости его магн. поля. Энергия микронных и позитронов плазмы от 10 мэв^2 до 10^4 мэв^2 . Ультрарелятивистская плазма пронизывается либо микронными, либо позитронным пучком частиц с энергией $(10^6 - 10^7) \text{ мэв}^2$ и концентрацией в $10^8 - 10^4$ раз меньше, чем концентрация плазмы. В сильном магн. поле П. электроны и позитроны плазмы и пучка из-за потерь на синхротронное излучение практически мгновенно теряют перпендикулярную магн. полю составляющую импульса и истекают из окрестностей нейтронной звезды, двигаясь почти вдоль магн. силовых линий. Т. о., электроны и позитроны имеют сильноперевосные одномерные ф-ция распределения по импуль-

сам. В такой плазме могут, в принципе, развиваться двухполюсная, циклотронная, филаментационная, дрейфовая и др. *неустойчивости плазмы*. Пока неясно, какие неустойчивости равновзоят в действительности и приводят к генерации радиоизлучения.

Наблюдения П. используются для решения большого числа актуальных проблем физики и астрофизики. Напр., при наблюдении PSR 1913 + 16, входящего в тесную двойную систему, впервые было получено косвенное подтверждение генерации *гравитационных волн*. Вследствие потерь энергии двойной системой на гравитач. излучение происходит сближение PSR 1913 + 16 и его звезды-компаньона. При этом орбитальный период системы уменьшается. Это уменьшение происходит в соответствии с общей теорией относительности, чем и подтверждается применимостью данной теории для описания процесса генерации гравитач. волн. Из анализа времени прихода импульсов опич. излучения PSR 0531 + 21 на разных частотах был получен верх. предел на изменение скорости света с изменением частоты: $\Delta c/c \leq 10^{-18}$. Этот предел на неск. порядков ниже полученного в лаб. условиях. По запаздыванию импульсов радиоизлучения PSR 0531 + 21 на разных частотах получено также ограничение на массу покоя реального фотона: $m_\gamma \leq 10^{-44} \text{ г}$. Данное ограничение более слабое, чем полученное в анализе земного магн. поля, однако анализ земного магнетизма даёт ограничение на массу виртуальных фотонов. Благодаря широкополосности, сильной линейной поляризации и импульсному характеру излучения П. являются идеальными зондами для исследования межзвёздной среды, самой природой разбрасываемы по объёму Галактики. С помощью наблюдений П. было найдено, напр., что ср. концентрация электронов в межзвёздной среде равна $0,03 \pm 0,1 \text{ см}^{-3}$. Было установлено также, что галактич. магн. поле однородно в масштабах $> 1 \text{ кпк}$ и в ср. составляет $(2,2 \pm 0,4) \cdot 10^{-6} \text{ Гс}$.

Лит.: М. Я. Ч е с т е р е в, Р. Т. Я л о р Д., Пульсары, пер. с англ. М., 1980; Т. У л о т Д. H., Stinebring D. R., Recent progress in the understanding of pulsars, «Ann. Rev. Astr. Astroph.», 1988, в. 24, р. 285. В. В. Соко.

ПУЛЬСАЦИИ ЗВЕЗД — собственные колебания звезд, проявляющиеся в их периодич. расширении и сжатии. Простейший вид собств. колебаний звезды — радиальные сферически-симметричные пульсации. В общем случае нерадиальных колебаний меняется и форма звезды, напр. звезда периодически принимает форму то вытянутого, то сплюснутого эллипсоида. Пульсации обуславливают переменность цефеид, звезд типа RV Тельца, RR Лирь, δ Цента, β Цефея, ZZ Кита и нек-рых др. типов физ. *переменных звезд*.

Большинство звезд обладает значит. концентрацией массы к центру: плотность вещества в центре на неск. порядков превышает ср. плотность звезды. Как следствие, П. а. гомологичны: относит. амплитуда колебаний в центре намного меньше, чем на поверхности.

Период P собств. колебаний звезды определяется в основном ср. плотностью вещества звезды ρ . Теоретич. соотношение имеет вид $P \sqrt{\bar{\rho}} = \text{const}$, где постоянная различна для разных мод и немного зависит от распределения вещества внутри звезды. Периоды большинства на перем. звезд согласуются с гипотезой радиальных колебаний в осн. моде (это колебание не имеет узлов вдоль радиуса), но у нек-рых звезд наблюдаются пульсации в оборотах или даже в неск. модах, в т. ч. нерадиальных. Для звезд конкретного типа первоначально, напр. типа RR Лирь, подобных друг другу по структуре, соотношение период — ср. плотность выполняется хорошо.

В пульсирующей звезде, за исключением её самых внеш. областей, колебания происходят почти адiabатически, в том смысле, что в течение цикла колебаний любой выделенный в звезде слой никак не изменяет проходящий через него поток излучения и пульсирует

как бы в условиях полной теплоизоляции, без теплообмена с окружающими слоями. Анализ адиабатич. П. а. не может дать информации о пульсат. устойчивости звезд, т. е. о нарастании или затухании малых колебаний с течением времени. Однако такой анализ обычно даёт хорошее описание механич. свойств звезд, в частности весьма точные значения периодов и правильное представление о распределении амплитуд пульсаций вдоль радиуса.

Возбуждение пульсаций звезд. Хотя неадиабатич. эффекты малы, они приводят к медленному изменению амплитуды П. а. Если в момент наб. сжатия выделенный в звезде слой получает нек-рое кол-во теплоты, то последующее расширение будет происходить при большем давлении, чем сжатие. В результате работа, совершённая слоем за цикл колебаний, будет положительной, т. е., как и в любой тепловой машине, будет иметь место превращение тепловой энергии в механическую. Такой слой будет вносить вклад в возбуждение (раскачку) колебаний. Если же в момент наб. сжатия слой теряет теплоту, то он вносит вклад в затухание колебаний. Если суммарная работа всех слоев в звезде за цикл колебаний положительна, то звезда пульсационно неустойчива (колебания нарастают), в противном случае — устойчива (колебания затухают).

Накопление или потеря теплоты выделенным слоем звездного вещества (если в слое нет источников энергии) зависит от того, какое изменение претерпевает идущий через слой поток излучения. В большинстве звезд поток излучения в момент наб. сжатия возрастает в направлении от центра к поверхности, т. е. через внеш. границу выделенного слоя выходит больше теплоты, чем поступает в слой через внутр. границу. Каждый слой в момент наб. сжатия теряет теплоту и способствует затуханию колебаний (звезда устойчива). Такое поведение потока излучения обусловлено в осн. изменениями коэф. непрозрачности звездного вещества $\kappa \times (\alpha, \rho)$, где α — *поглощения коэффициент*. Обычно при сжатии κ уменьшается, причём из-за негомолотности колебаний уменьшение на внеш. границе выделенного слоя будет большим, чем на внутренней, и поэтому слой будет терять теплоту. Нек-рый отток тепла на слой при сжатии может иметь место и при постоянном κ .

Существование большого числа длительно пульсирующих звезд указывает на то, что в пульсирующей звезде должен постоянно действовать механизм раскачки колебаний. Для классич. переменных звезд (шфеид, переменных типа RR Лир и др. звезд в полосе нестабильности, см. Герципрунга — Рассела диаграмму) самым эффективным оказывается действие зон частичной ионизации водорода и гелия, особенно зоны второй ионизации гелия. Раскачивающее действие этих зон основано на том, что при сжатии они способны не только задерживать проходящий через них поток излучения, а при расширении — наоборот, усиленно терять энергию, отдавая её внеш. слоям. Действительно, в зоне ионизации энергии, выделяющейся при сжатии, идёт не только на нагрев газа, но и на его ионизацию. Относит. изменения плотности $\delta\rho/\rho$ связаны с относит. изменениями темп-ры $\delta T/T$ соотношением: $\delta T/T \approx (\gamma - 1)\delta\rho/\rho$. В зоне второй ионизации гелия $\gamma \approx 1,2 - 1,3$ вместо обычного значения $\gamma = 5/3 \approx 1,67$ для идеального одноатомного газа, т. е. при сжатии повышение темп-ры в зоне ионизации оказывается меньшим, чем в прилегающих более глубоких слоях. Для заданного коэф. непрозрачности поток излучения $\sim T^4$, поэтому при сжатии в зоне ионизации произойдёт задержка потока излучения, идущего изнутри. Данный эффект, связанный с прямым влиянием темп-ры на поток излучения, наз. γ -механизмом. Значительную, если не основную, роль играют и изменения непрозрачности. Коэф. непрозрачности зависит от T и ρ по закону $\kappa \sim \rho^m T^{-n}$ ($m \approx 0,8 - 1,0$; $n \approx 3 - 4$). Из-за малых вариаций темп-ры в зоне ионизации при П. а. измене-

ния κ определяются в осн. изменениями плотности, т. е. при сжатии κ увеличивается (в др. областях звезд κ уменьшается из-за сильного понижения темп-ры). Поток излучения обратно пропорционален κ , поэтому из-за увеличения κ в зоне ионизации при сжатии также произойдёт задержка потока излучения. Этот эффект, наз. χ -механизмом. Рассматриваемые механизмы не являются независимыми, их разделение довольно искусственно.

Эффекты изменений темп-ры и непрозрачности сами по себе ещё недостаточны для обеспечения раскачки П. а. Во внутр. частях зоны ионизации, где κ уменьшается в направлении от центра (достига минимума около середины зоны), происходит задержка потока излучения при сжатии; во внешних же частях этой зоны, где κ увеличивается в направлении от центра, при сжатии может произойти усиленный отток тепла, т. е. будет вклад в затухание П. а. Суммарный раскачивающий эффект зоны ионизации может оказаться малым или вообще отсутствовать. Из-за очень высокой плотности самых внеш. слоев их пульсации характеризуются сильным теплообменом между отд. слоями, и оказывается, что такие разреженные слои не способны эффективно задерживать проходящий через них поток излучения: в любой момент времени выделенный слой теряет через свою внеш. границу столько же энергии, сколько получает изнутри. Т. о., самые внеш. слои не вносят никакого вклада в возбуждение или затухание П. а.

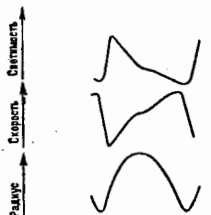
Следовательно, для создания заметного раскачивающего эффекта зона ионизации должна располагаться на нек-рой оптм. глубине под поверхностью звезды, так, чтобы в её внутр. части происходило сильное возбуждение пульсаций и в то же время во внеш. части и выше неё благодаря неадиабатич. эффектам практически отсутствовало затухание. Именно такая ситуация, по-видимому, реализуется в зоне He II \approx He III переменных звезд. Вторая ионизация гелия происходит при темп-ре ок. $4 \cdot 10^4$ К (в середине зоны). Поэтому в звездах с разной *эффективной температурой* T_0 зона ионизации расположена на разл. глубине под поверхностью. Если она слишком близка к поверхности (T_0 слишком велика), то колебания всей зоны характеризуются сильной неадиабатичностью и зона не вносит вклада в возбуждение П. а. Если же зона лежит слишком глубоко (T_0 слишком мала), неадиабатич. эффекты малы по всей зоне, и поэтому раскачивающее действие внутр. части компенсируется затуханием во внеш. части. Т. о., должен существовать довольно узкий диапазон значений T_0 , для к-рого возможно возбуждение пульсаций в зоне второй ионизации гелия. Существование на диаграмме Герципрунга — Рассела узкой, почти вертикальной полосы нестабильности, наследственной переменными звездами, служит доказательством эфф. действия рассмотренного иониз. механизма в классич. переменных звездах.

Аналогично зоне второй ионизации гелия могут действовать зоны ионизации водорода и первой ионизации гелия, особенно в относительно холодных звездах. Однако в оболочках холодных звезд перенос энергии осуществляется преим. конвекцией, к-рая, по-видимому, препятствует возбуждению П. а. Почти несомненно, что именно появление эфф. конвекции во внеш. слоях звезд и определяет положение низкотемпературной границы полосы нестабильности на диаграмме Герципрунга — Рассела.

Неявные пульсации звезд. Анализ пульсат. устойчивости звезд относительно малых возмущений (линейный анализ устойчивости) не даёт представления об амплитуде установившихся П. а., а также о форме кривых блеска (зависимостей блеска от времени) и лучевой скорости. Зависимость эффективности механизмов возбуждения и затухания от амплитуд колебаний исследуется в нелинейной теории П. а. Из-за конечной поглощ. способности зон частичной иониза-

длина нарастание амплитуды колебаний не будет происходить неограниченно, при определ. амплитуде достигается баланс между раскачивающим действием зоны ионизации и затуханием в более глубоких областях, и в дальнейшем колебания происходят с пост. амплитудой. Рассчитанные амплитуды установившихся пульсаций цефеид и звезд типа RR Лирь согласуются с наблюдаемыми значениями. Для моделей звезд типа В Шита раскачивающий эффект зон ионизации при амплитудах, близких к наблюдаемым, ещё далёк от насыщения, и предлагают, что ограничение амплитуды пульсаций этих звезд связано с взаимодействием разл. мод колебаний, в данном случае с перекачкой энергии от неустойчивых мод к устойчивым.

Типичное для классич. цефеид и звезд типа RR Лирь поведение поверхностных характеристик при установившихся нелинейных пульсациях показано на рис. Вариации светимости или блеска определяются в осн. изменениями эфф. темп-ры, достигающими для этих звезд ок. 1500 К. Кривая лучевой (радиальной) скорости является приблизительно зеркальным отражением



Изменение поверхностных характеристик модели звезды в Цефеид при установившихся пульсациях (по результатам нелинейных расчетов). Амплитуда колебаний блеска составляет 1,2 абсолютной величины, лучевой скорости — 90 км/с, радиуса — 13% (нормализованная амплитуда). Плавные кривые и огибающие амплитуды качественно согласуются с наблюдаемыми.

лучевой блеска. Поэтому звезда оказывается наиб. яркой не в момент наиб. сжатия, как можно было бы ожидать из простейших соображений, а при прохождении равновесного состояния во время последующего расширения. Данный эффект, называемый фазовым запаздыванием, связан с быстрым перемещением зоны ионизации водорода по звездному веществу в фазе макс. сжатия, благодаря чему эта зона примерно через четверть периода наиб. близко подходит к поверхности. Из теории лучистого переноса в звездных атмосферах следует, что светимость звезды тем больше, чем меньше масса слоя, лежащего над областью ионизации водорода. Из-за асимметрии кривых типичное фазовое запаздывание составляет не четверть, а 0,4–0,2 периода. Теория радиальных колебаний, возбуждаемых ионизацион. механизмами, хорошо объясняет осн. особенности П. э. в полосу неустойчивости: периоды и амплитуды пульсаций, характер изменений блеска и лучевой скорости и их взаимосвязь, положение и наклон самой полосы неустойчивости. Анализ нелинейного взаимодействия мод вследствие простого или параметрич. резонанса позволяет выявлять такие эффекты, как модуляция амплитуды колебаний, двухпериодич. пульсации нек-рых цефеид и др. Пульсации долгопериодич., доуправляемых и неправильных переменных изучены значительно хуже из-за трудностей, связанных со сложным взаимодействием пульсаций и конвекции, с сильными нелинейными эффектами, приводящими к образованию ударных волн и пульсаций, потере массы, с проблемами переноса излучения в холодных протяженных атмосферах, с высокой степенью неадиабатичности пульсаций вследствие соизмеримых динамической и тепловой шкал времени для этих звезд (см. *Волочуца и др.*). Нелинейные эффекты могут приводить также и трансформации правильных колебаний в хаотические, напр. через последоват. двойные периоды.

Нерадиальные пульсации звезд. Переменность белых карликов, др. горячих вырожденных звезд, нек-рых переменных типа β Цефеид, звезд *спектрального класса В* с перем. профилями спектральных линий, нек-рых магн. звезд с аномальными хим. состава вызвана, вероятно, их нерадиальными колебаниями. Наряду с негравитационной геом. формой нерадиальные колебания звезды отличаются от радиальных ещё рядом особенностей. Нерадиальный аналог радиальных пульсаций — акустические, или p -моды, обусловленные эффектами сжимаемости вещества. Для этих мод систематика периодов (в частности, увеличение собств. частоты с возрастанием порядка обертона) и распределение амплитуды вдоль радиуса (характер негеомологичности колебаний, расположенное узлов) подобны радиальным пульсациям. Др. ветвь частотного спектра нерадиальных колебаний — гравитационные, или g -моды, аналогичные внутр. гравит. волнам в океане и земной атмосфере и обусловленные эффектами плавуучести. Их периоды больше периодов радиальных и нерадиальных акустич. мод и растут с увеличением порядка моды. Относит. амплитуды колебаний в недрах, как правило, больше, чем во внеш. слоях; в недрах же локализованы узлы и лучности обертонов. Типичные периоды наблюдаемых осциллирующих белых карликов составляют 100–4000 с, их можно объяснить только гравитационными, т. е. к. периоды радиальных пульсаций этих звезд не превышают неск. секунд. На нерадиальный характер пульсаций др. звезд указывают, в частности, выявленные из наблюдений и предсказываемые теорией закономерности частотного спектра мультипериодич. пульсаций, напр. эквидистантность частот высоких акустич. обертонов.

Наряду с классич. ионизацион. механизмами возбуждения П. э. определ. роль может играть возбуждение посредством термоядерных реакций, сильно чувствительных к темп-ре; предложен также ряд механизмов, обусловленных конвекцией и магн. полем.

Солнце также является своеобразной пульсирующей звездой, испытывающей разл. виды радиальных и нерадиальных колебаний с периодами от неск. минут до неск. часов. Общее число уверенно идентифицированных собств. колебаний составляет более тысячи. В силу того, что частоты разл. мод по-разному чувствительны к распределению вещества вдоль радиуса, наблюдаемая совокупность колебаний позволяет проводить всеобщее исследование эволюции солнечных недр (см. *Солнечная сейсмология*).

Лит.: Жеванни С. А., Теория звездных пульсаций, в кн.: Пульсирующие звезды, М., 1979; Nonradial oscillations of stars, Tokyo, 1979; Коке Д. и др., Теория звездных пульсаций, пер. с англ., М., 1983; Северный Я. А. В., Некоторые проблемы физики Солнца, М., 1988.

ПУЧКОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ — одна из наиб. распространенных неустойчивостей в плазме, обусловленная резонансным взаимодействием пучка заряд. частиц, движущегося в плазме, с возбуждаемыми им волнами. П. н. предсказана А. И. Ахмезером, Л. Б. Файнбергом (1949), а также независимо Д. Бомом (D. Bohm), Е. Гроссом (E. Gross, 1949) и экспериментально обнаружена И. Ф. Харченко, Я. Б. Файнбергом, Е. А. Коряловым, А. К. Березиным и др. (1957–1958).

П. н. заключается в том, что при первоначально невозмущенном движении пучка с пост. плотностью и скоростью через плазму существующие в нём и в плазме флуктуации плотности заряда и порождаемые ими эл.-статич. или эл.-магн. поля самопроизвольно нарастают и распространяются в виде волн с экспоненциально увеличивающейся амплитудой. Экспоненц. рост имеет место только на начальной, линейной стадии развития П. н., в дальнейшем ряд нелинейных процессов ограничивает этот рост. Возникновение неустойчивости в системе плазма — пучок оказывается возможным, т. к. она неравновесна; неравновесность создаётся пучком, на к-рого черпается энергия воз-

буждаемых волн. П. н. приводит к возникновению турбулентности и ограничению предельных токов в системе плазма — пучок. П. н. используется: для возбуждения в плазме очень интенсивного когерентного излучения от радиодиапазона до субмиллиметрового и даже, возможно, светового; для ускорения заряж. частиц волнами, возбуждаемыми пучками в плазме; в неравновесной плазме ω_p и т. п. П. н. можно управлять, что позволяет даже отриц. эффекты превратить в полезные. Напр., использовать эффект турбулентности плазмы для пучковой и турбулентного нагрева до термодермных темп-р.

Условия возникновения пучковой неустойчивости. П. н. возникает, если имеет место к-л. элементарный механизм резонансного взаимодействия волны с частицами пучка, приводящий к излучению волн отд. частицей, такой как, напр., эффект Черенкова, нормальный и аномальный эффекты Доплера и т. п. Чтобы спонтанное излучение отд. частицы превратилось в индуцированное или когерентное индуцированное излучение, необходима группировка частиц пучка в области тормозных фаз волн, где они отдают энергию ал.-магн. полю. В большинстве случаев группировка происходит автоматически, т. е. имеет место автомодуляция. Если в системе плазма — пучок наряду с процессами излучения есть и процессы поглощения, то для развития П. н. необходимо, чтобы число частиц пучка со скоростями $v > v_0$ (v_0 — фазовая скорость волны) превышало число частиц с $v < v_0$, т. е. $\partial f_0/\partial v > 0$, где f_0 — ф-ция распределения электронов пучка. Если $\partial f_0/\partial v < 0$, преобладают процессы поглощения, т. е. имеет место *Ландау затухание*. С квантовой точки зрения возникновение П. н. означает, что благодаря преимуществ. заселению верх. уровней энергии (частиц пучка) происходит больше актов индукции, испускания, чем индукции, поглощения. Наиб. полное описание П. н. достигается с помощью самосогласов. систем ур-ний, состоящих на кинетич. ур-ния Власова для плазмы и пучка и ур-ний Максвелла. Однако при рассмотрении ряда разновидностей П. н. достаточно ограничиться гидродинамич. рассмотрением. В частности, это относится к П. н., возникающей при взаимодействии моноэнергетич. пучка (или пучка с очень малым разбросом по скоростям) с холодной плазмой (см. *Плазменно-пучковый разряд*, *Плазменная электроника*). В этом случае шкрямент неустойчивости $\delta = \Gamma \omega$ имеет макс. значение $\delta_{\text{макс}} \sim \omega_p (n_b/n_p)^{1/2}$. Малый разброс по скоростям пучка означает, что $\Delta v \ll \delta/k$, т. е. $\Delta v/v \ll (n_b/n_p)^{1/2}$, и весь пучок как целое находится в резонансе с неустойчивыми волнами (здесь n_b — плотность пучка, n_p — плотность плазмы, k — волновое число, ω_p — плазменная частота). Если разброс по скоростям не мал, $\Delta v \gg \delta/k$, то для исследования П. н. используются кинетич. рассмотрение. Существует большое разнообразие П. н., напр. неустойчивости при взаимодействии новых пучков с плазмой, неустойчивости относительно движения электронов и новых пучков (неустойчивость Буккера — Буемана), целый набор П. н. при наличии внеш. пост. магн. поля.

Нелинейное взаимодействие. С ростом амплитуды возбуждаемых волн возникает нелинейные эффекты, ограничивающие амплитуду волн и приводящие к изменению параметров системы плазма — пучок благодаря обратному воздействию возбуждаемых волн. При возбуждении широких волновых пакетов, фазовые скорости к-рых плотно заполняют область изменения фазовых скоростей, области захвата частиц пучка соседними волнами перекрываются. При этом благодаря случайному характеру фаз волн движение частицы аналогично броуновскому и происходит диффузия резонансных частиц в пространстве скоростей. Для описания процессов взаимодействия пучка с плазмой в этом случае возможен статистич. подход.

Система ур-ний *квазилинейной теории плазмы* описывает диффузию частиц в пространстве скоростей, обрат-

ное влияние возбуждаемых волн, увеличение разброса по скоростям в пучках и нагрев плазмы, но не учитывает др. нелинейные эффекты, напр. нелинейное взаимодействие волн между собой. Как следует из квазилинейной теории, около трети энергии пучка переходит в энергию возбуждаемых волн. Спектр сильно возбуждаемых волн уширяется, и значительно увеличивается длина релаксации пучка.

При взаимодействии с плазмой моноэнергетич. пучки вначале возбуждаются очень узкий пакет волн с макс. инкрементом от $k_0 = \omega_p/v$ и с полушириной волнового пакета $\Delta k_0 = (n_b/n_p)^{1/2}/k_0$. При возрастании амплитуды волн в m раз ширина спектра уменьшается в \sqrt{m} раз, т. е. волновой пакет сильно сужается, и возбуждаемому волну можно считать монохроматической. С дальнейшим ростом амплитуды волн происходит захват частиц пучка в потенциальную яму волн. При осциллирующих в потенциальной яме густоты, на к-рые разбивается электронный пучок, попеременно смещаются в область тормозных фаз волны и отдают энергию, а затем — в область ускоряющих фаз и получают энергию от волны, так что в среднем обмен энергией между электронами пучка и волной уже не происходит. Решение на ЭВМ систем ур-ний, описывающих возбуждение монохроматич. волны на величнейей стадии, представляет собой монохроматич. волну с осциллирующей во времени и в пространстве амплитудой.

Пучковая неустойчивость в релятивистских пучках. Инкремент П. н., возбуждаемой релятивистским пучком, меньше из-за релятивистского возрастания продольной и поперечной масс электронов пучка (см. *Плазменная электроника*). Однако инкремент не является единств. характеристикой эффективности плазменно-пучкового взаимодействия. Важны доля энергии пучка, передаваемая им на возбуждение волн, макс. амплитуда этих волн, а также время передачи энергии плазме, т. е. время релаксации пучка. Особенностью взаимодействия релятивистского пучка с плазмой является то, что обратное влияние возбуждаемых пучком волн, даже при значит. энергетич. разбросе, не приводит к большому разбросу по скоростям, поэтому взаимодействие продолжается дольше и доля энергии, передаваемая пучком плазме, значительно больше, чем в нерелятивистском случае ($\sim 0,35$ энергии пучка). Максимально достижимая напряженность электрич. поля также значительно больше, чем в нерелятивистском случае.

Оси. механизмом, ограничивающим П. н. в слабо-турбулентной плазме, является индукцион. рассеяние ленгмювских волн на ионах, к-рое приводит к перекачке колебаний из резонансной с пучком области в область больших фазовых скоростей. В сильнотурбулентной плазме существ. влияние на развитие П. н. оказывает *модуляционная неустойчивость*, к-рая возникает при достаточно высоком уровне энергии возбуждаемых волн и приводит к перекачке энергии возбуждаемых волн в область малых фазовых скоростей, где происходит их диссипация в результате затухания Ландау. Откачка колебаний из резонансной области может либо вообще сорвать П. н., либо существенно снизить уровень энергии возбуждаемых волн.

Т. к. П. н. возникают в результате резонансного взаимодействия волн с частицами пучка, сводящегося к неск. элементарным эффектам, а также к фазировке и группировке частиц, то устранить или ослабить неустойчивость можно созданием условий, при к-рых отсутствует элементарные процессы, фазировка и группировка невозможны. Напр., если на вход системы плазма — пучок задать сигнал с амплитудой, превышающей флуантуационную, или промодулировать пучок на входе системы, то группировка и фазировка создаются только для возбуждения волны заданной частоты, а возбуждение всех остальных волн невозможно. Нарушить условия резонанса, необходимые для развития П. н., можно изменением фазовой скорости волны, напр. из-за

ведородности плотности плазмы или скоростей бунка в результате его торможения. Условия возникновения резонансов могут нарушаться также из-за величинных эффектов в движении отд. частиц, а также величинных эффектов, обусловленных коллективными взаимодействиями. Эти и др. способы управления П. и. были теоретически исследованы и экспериментально доказаны.

Лит.: Фангбергер Я. В., Взаимодействие пучков заряженных частиц с плазмой, «Атом. энергия», 1961, т. 11, в. 3, с. 312. Велдман М. А., Рогов Л. Д., Квазилинейные эффекты в потоковых неустойчивостях, в сб.: Вопросы теории плазмы, в. 6, М., 1972; Электродинамика плазмы, под ред. А. И. Ахвердиева, М., 1974; Папирев В. А., Шендеров В. И., Взаимодействие волна-частица в неравновесных средах, «Изв. вузов. Радиофизика», 1976, т. 19, в. 5-6, с. 787; Александров А. Ф., Богданевич Л. С., Рудаков А. А., Основы электродинамики плазмы, 2 изд., М., 1984; Велдман М. В., Электронные пучки в плазме, в кн.: Итоги науки и техники. Сер. Физика плазмы, т. 5, М., 1984. См. также лит. при ст. Плазменная электродинамика.

П. ФОНДА СЕРИЯ — спектральная серия в спектре атома водорода.

ЧЕТНОСТЬ (пространственная четность) — характеризует поведение волновой функции при пространственной инверсии (отражении пространственных координат $r \rightarrow -r$). См. Внутренняя четность. Четность, ПЬЕЗА (от греч. *piezo* — давлению (пь, рз) — единица давления в механич. напряжениях в МТС системе единиц, $1 \text{ пз} = 1 \text{ сН/м}^2 = 10^9 \text{ Па} = 10^4 \text{ дин/см}^2 = 0,1012 \text{ кгс/см}^2 = 9,87 \cdot 10^8 \text{ атм} = 7,50 \text{ мм рт. ст.}$).

ПЬЕЗОКЕРАМИКА — поликристаллич. светозвуков. материалы, обладающие после их поляризации в электрич. поле устойчивыми и хорошо выраженными пьезоэлектрич. свойствами. Способ изготовления П., её механич. свойства и структура аналогичны обычной керамике. По структуре неполиаризов. П. представляет собой совокупность зёрен со случайной ориентацией кристаллографич. осей, причём каждый кристаллит имеет сложную доменную структуру, а полная спонтанная поляризация $P = 0$. Зёрна имеют размеры 2—100 мкм. Размеры зёрен влияют на свойства П. (важна П. с мелкими зёрнами).

В процессе поляризации в пост. электрич. поле дипольные моменты доменов всех зёрен ориентируются вдоль поля. После выключения поля эта ориентация сохраняется и керамика приобретает пьезирующую аннотропию, т. е. переводится в класс пьезоэлектриков с симметрией C_{6v} (см. Пьезоэлектрики).

Большинство составов П. основано на хим. соединениях с ф-лой ABO_3 (напр., $BaTiO_3$, $PbTiO_3$) с кристаллич. структурой типа перовскита и рвалчатыми твёрдыми растворами на их основе (напр., системы $BaTiO_3 - CaTiO_3$; $BaTiO_3 - CaTiO_3 - CoCo_3$; $NaNbO_3 - KNbO_3$). Особенно широко используются в качестве пьезоэлектриков составы системы $PbTiO_3 - PbZrO_3$ (т. н. система PZT или ЦТС). Практич. интерес представляет также ряд соединений с ф-лой AB_2O_6 , напр. $PbNb_2O_6$, имеющих весьма высокую темп-ру (570°C), что позволяет работать при высоких темп-рах. П. является наиб. широко применяемым пьезоэлектрич. материалом.

Лит.: Физическая акустика, под ред. У. Мэсона, пер. с англ., т. 1, ч. 4, М., 1964; Глозман И. А., Пьезоэлектрики, 2 изд., М., 1972; Яффе Б., Кук У., Яффе Г., Пьезоэлектрическая керамика, пер. с англ., М., 1974; Казаки И. К., Технология керамических диэлектриков, пер. с япон., М., 1976. Р. Е. Мазокин.

ПЬЕЗОМАГНЕТИЗМ (пьезомагнитный эффект) — возникновение в веществе спонтанного магнитного момента при наложении упругих напряжений. П. может существовать только в антиферромагнетиках и ферромагнетиках и принципиально невозможен в пара- и диамагнетиках.

Термодинамич. рассмотрение вопроса о П. основывается на выделении и изучении в разложении термодинамического потенциала Φ членов, линейных по магн. полю H_i и по одной из компонент тензора упругих напряжений σ_{jk} :

$$\Phi = \Phi_0 - \sum_{ijk} \Lambda_{ijk} H_i \sigma_{jk} \quad (*)$$

Если все преобразования магн. симметрии данного кристалла оставляют инвариантным хотя бы один член в этом выражении, то соответствующий коэф. Λ_{ijk} (модуль П.) будет отличен от нуля и в кристалле будет возникать пьезомагн. момент $m_i = -\partial\Phi/\partial H_i = \sum_{ijk} \Lambda_{ijk} \sigma_{jk}$, зависящий от приложенного напряжения σ_{jk} . Эта идея впервые была высказана В. Фойтом [1]. Однако он ошибочно считал, что достаточно учитывать только кристаллографич. симметрию.

Пара- или диамагнитный кристалл не может быть пьезомагнетиком, поскольку в группу магн. симметрии такого кристалла самостоятельно входит элемент инверсии времени R , к-рый изменит знаки магн. полей и моментов на обратные (см. Магнитная симметрия). Поэтому для пара- и диамагнетиков все компоненты пьезомагн. тензора Λ_{ijk} тождественно равны нулю. В веществах, обладающих упорядоченной магн. структурой (в ферромагнетиках и антиферромагнетиках), R встречается только в комбинациях с др. элементами симметрии. Поэтому в принципе такие вещества могут быть пьезомагнетиками [2]. Симметричный анализ позволил установить все классы магн. симметрии, к-рые допускают П. Их оказалось 66, и для всех найден вид тензоров Λ_{ijk} . Благодаря симметрии тензора σ_{jk} пьезомагн. тензоры могут быть представлены в виде матриц 3×6 , и число таких матриц равно 46 [3].

Пьезомагн. момент сравнительно мал. Поэтому практически наблюдать его можно только в антиферромагнетиках, к-рые в нормальных условиях не обладают спонтанным магн. моментом. Теоретич. исследование магн. симметрии известных антиферромагнетиков позволило И. Е. Дзюлокинскому [4] (ещё до того, как были найдены все магн. классы, допускающие П.) найти среди них ряд веществ (Fe_2O_3 , $FeCO_3$, MnF_2 , CoF_2 , FeF_2), а к-рых должен наблюдаться П.

П. в антиферромагнетиках тесно связан с явлением слабого ферромагнетизма. Так же, как и магн. момент слабых ферромагнетиков, пьезомагн. момент может быть направлен перпендикулярно к направлению спонтанной намагниченности магнитных подрешёток или параллельно ему. В первом случае возникает скос векторов подрешёток, приводящий к возникновению пьезомагн. момента. Продольный П. связан с изменением намагниченности подрешёток.

Экспериментально П. обнаружен в 1959 в антиферромагн. кристаллах MnF_2 и CoF_2 [5]. В этих кристаллах в соответствии с соображениями симметрии отличен от нуля только три компонента пьезомагн. тензора: $\Lambda_{xyz} = \Lambda_{xyz}$ и Λ_{xzy} . Для CoF_2 пьезомагн. модули при темп-ре $20,4 \text{ K}$ имеют следующие значения: $\Lambda_{xyz} = 2 \cdot 10^{-9} \text{ Гс-см}^2/\text{кг}$ и $\Lambda_{xzy} = 0,8 \cdot 10^{-9} \text{ Гс-см}^2/\text{кг}$. На примере антиферромагн. фторидов легко понять микроскопич. природу продольного пьезомагн. эффекта.



На рис. 1 показана схема расположения ионов в деформированной тетрагональной решётке, когда кристаллографически эквивалентные узлы 1 и 2 после сдвиговой деформации плоскости xy превращаются в эквивалентными. При этом расстояние d_1 до ближайших ионов фтора для магн. ионов в подрешётке 1 увеличивается, а для ионов в подрешётке 2 — уменьшается.

Очевидно, что при этом изменения величины намагниченности подрешёток должны быть противоположными и их равенство будет нарушаться [6]. Из рис. 2 видно,

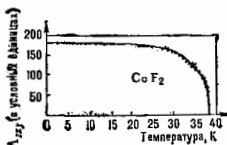


Рис. 2. Температурная зависимость модуля пьезомагнитного коэффициента $\Delta\lambda_{11}$ у CoF_2 (точки — данные эксперимента).

что температурная зависимость пьезомагн. модуля аналогична температурной зависимости намагниченности подрешёток.

П. существенно зависит от доменной структуры антиферромагнетика. 180-градусные домены отличаются знаком антиферромагн. вектора $L = M_1 - M_2$ (M_1 и M_2 — намагниченности подрешёток), а компоненты тензора П. линейно зависят от компонент вектора L . В многодоменном антиферромагн. образце П. может быть сильно ослаблен. Поэтому П. в чистом виде наблюдается в однодоменных образцах. При перемативании однодоменного образца, обладающего пьезомагн. моментом, происходит переворот домена и соответственно векторы намагниченности подрешёток поворачиваются на 180°. Используя П., легко получать однодоменные антиферромагн. кристаллы, охлаждая их из парамагн. состояния в магн. поле при соответствующей деформации. Это было подтверждено методами нейтронографии.

П. наблюдался также в FeSO_4 и в низкотемпературной модификации $\alpha = \text{Fe}_2\text{O}_3$. Магн. симметрия обоих веществ одинакова, и в них наблюдаются следующие отличные от нуля компоненты тензора П.: $\Delta\lambda_{11} = -\Delta\lambda_{22} = -(\frac{1}{2})\Delta\lambda_{33}$ и $\Delta\lambda_{12} = \Delta\lambda_{21}$. Их величина примерно на порядок меньше, чем у CoF_2 . В высокотемпературной модификации $\alpha = \text{Fe}_2\text{O}_3$ удалось измерить только один модуль П. — $\Delta\lambda_{11}$, величина к-рого тоже на порядок меньше, чем у CoF_2 .

Из фл-ы (*) видно, что наряду с П. должен существовать обратный эффект — линейная магнитострикция, при к-рой компоненты тензора деформаций u_{jk} линейно связаны с магн. полем: $u_{jk} = -\partial\Phi/\partial\sigma_{jk} = \Delta\lambda_{jk}H_i$. Знак линейной магнитострикции, как и в случае П., зависит от знака вектора L , характеризующего образовавшееся доменное состояние образца. Линейная магнитострикция наблюдалась в CoF_2 и $\alpha = \text{Fe}_2\text{O}_3$ (в обеих антиферромагн. модификациях). В ходе исследования линейной магнитострикции в этих веществах было обнаружено, что в сильных магн. полях знак магнитострикции может скачком изменяться, что указывает на индуцированное полем скачкообразное изменение доменной структуры антиферромагнетика (поворот вектора антиферромагнетизма L на 180°).

Линейная магнитострикция наблюдалась также при спин-переворотах, переходах в ортоферритах (YFeO_3 и DyFeO_3) и ортохромитах (YCrO_3) (см. Магнитный фазовый переход). В этих соединениях в орвелд. интервале значений температур направление антиферромагн. вектора L плавно изменяется от одного кристаллограф. направления к другому. При этом, как показывает симметричный анализ, должна наблюдаться линейная магнитострикция, приводящая к моноклинному искажению орторомбич. решётки. Направление вектора L антиферромагн. домена и в этом случае определяет знак магнитострикции. Линейная магнитострикция даёт значит. вклад в магнитоупругие свойства антиферромагнетиков вблизи Нееля точки T_N .

Симметричным аналогом линейной магнитострикции является эффект линейного но магн. поля магн. двулучепреломления. В отличие от обычного квадратного

по полю Коттона—Мутона эффекта, линейное двулучепреломление наблюдается в одноосных антиферромагнетиках при приложении магн. поля вдоль оси антиферромагнетизма [7].

Лит.: 1) Volz G. W., Lehrbuch der Kristallphysik, 3 Aufl., Leipzig — В. 1928; 2) Виллгардт В. М. и Яцен В. М.: О магнитной симметрии кристаллов, «ЖТФ», 1956, т. 30, с. 564; 3) Дэйл Р. Р., Symmetry and magnetism, Amst., 1964; 4) Дэйл Р. Р. и Кенни И. Е., К вопросу о пьезомагнетизме, «ЖТФ», 1957, т. 33, с. 807; 5) Боревич И. Р. и Кенни И. Е., Пьезомагнетизм в антиферромагнитных фторидах никобата и марганца, «ЖТФ», 1960, т. 38, с. 1088; 6) Могила Т. Р., Pseudo-magnetism in CoF_2 , J. Phys. Chem. Solids, 1959, v. 11, p. 73; 7) Харченко Н. Ф., Ермеженко В. В., Бельман Д. Л., Индуцированное продольным магнитным полем понижение оптического класса антиферромагнитного кристалла, «Письма в ЖТФ», 1978, т. 28, с. 351. А. С. Боревич-Рожков.

ПЬЕЗОМЕТР (от греч. *piezo* — давить и *metreo* — измерю) — прибор для определения изменения объёма вещества, находящегося под гидростатич. давлением (при практически пост. темп-ре). Конструкция П. определяется диапазоном применяемых давлений p и темп-р T , агрегатным состоянием вещества, его сжимаемостью. В разл. типах П. с изменением p может меняться либо объём V вещества, либо его масса m (при пост. V). Пьезометрич. измерения используют для получения данных о сжимаемости вещества, для исследования диаграмм состояния, фазовых переходов и др. физико-хим. процессов.

Для определения сжимаемости жидкостей и твёрдых тел при $p \sim 10^6$ — 10^{10} Н/м² применяют П. пьезоупругого или поршневого типа (см. рис. 1 а) в ст. Давление высокое). В процессе сжатия определяются V (по среднему поршней) и p . Передающей давление средой часто служит само исследуемое вещество. При $p \sim 10^6$ — 10^{10} Н/м² сжимаемость определяют также др. методами, напр. рентгенографическими (см. Рентгенография материалов). Изменение линейных размеров тел под гидростатич. давлением измеряют линейными П. (т. н. dilatометрами).

П. наз. также толстоствольные сосуды в установках высокого давления с цилиндром, каналом, не предназначенные для измерения сжимаемости. В зарубежной лит-ре П., кроме того, наз. приборы для измерения давления в проточных системах, давления воды в морских глубинах, газов в канале ствола орудия.

Лит. см. при ст. Давление высокое. Л. Д. Липицкая.

ПЬЕЗОТИПЫЙ ЭФФЕКТ (фотоупругость, эластооптический эффект) — возникновение оптич. анизотропии в первоначально изотропных твёрдых телах (в т. ч. полимерах) под действием механич. напряжений. П. э. открыт Т. И. Зеебеком (Т. J. Seebeck) в 1813 и Д. Брюстером (D. Brewster) в 1816. П. э. — следствие зависимости диэлектрич. проницаемости от деформации; проявляется в виде двойного лучепреломления и дихроизма, возникающих под действием механич. нагрузок. При одноосном растяжении или сжатии прозрачное изотропное тело приобретает свойства оптически одноосного кристалла с оптич. осью, параллельной оси растяжения или сжатия. При более сложных деформациях, напр. при двустороннем растяжении, образец становится оптически двуосным.

П. э. обусловлен деформацией электронных оболочек атомов и молекул по ориентации оптически анизотропных молекул либо их частей, а в полимерах — раскручиванием и ориентацией полимерных цепей. Для малых одноосных растяжений и сжатий выполняется соотношение Брюстера $\Delta n = Kp$, где Δn — величина двойного лучепреломления (разность показателей преломления для обыкновенной и необыкновенной волн), P — напряжение, K — упругооптич. постоянная (постоянная Брюстера). Для стёкол $K = 10^{-13}$ — 10^{-12} см²/дин (10^{-12} — 10^{-11} м²/Н).

П. э. используется при исследовании напряжений в механич. моделях (см. Поляризационно-оптический метод исследования).

Лит.: Ландберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Фокс Х. М., Волноупругие пер. в анал. т. 1—2, М.—Л., 1948—50; Бир Г. Л., Пиккус Г. В., Симметрия и деформа-

Пьезоэлектрические коэффициенты и полупроводниковые характеристики пьезотрипловых полупроводников

Кристалл	Группа симметрии	ϵ_{ij} , Кл/м ²					ϵ_{ij} , Кл/м ²					ϵ/ϵ_0^{**}	K_c^* , %	K_i^* , %
		ϵ_{11}	ϵ_{12}	ϵ_{13}	ϵ_{22}	ϵ_{23}	ϵ_{33}	ϵ_{31}	ϵ_{32}	ϵ_{33}	ϵ_{31}			
Te	32	0,38	0,5	0,72	0	0	0	0	0	0	0	$\epsilon_1=33; \epsilon_2=53$	35	53
GaAs	43 m	1,43	0	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	12	2	7
GaP	—	2,49	0	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	8,5	—	11
InSb	—	0,18	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	16	3	4
InAs	—	3,8	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	8,3	—	5,4
β -ZnS	—	3,6	0	0	0	-0,07	0	0,14	0,14	0,14	0,14	$\epsilon_1=8,3; \epsilon_2=8,8$	28	32
ZnO	6 mm	3,4	0	0	0	-0,59	-0,61	1,14	1,14	1,14	1,14	$\epsilon_1=9,0; \epsilon_2=9,5$	15	19
GdS	—	2,4	0	0	0	-0,21	-0,24	0,44	0,44	0,44	0,44	$\epsilon_1=9,7; \epsilon_2=10$	2,8	2
6H-SiC	—	3,0	0	0	0,99	0,08	0	0,2	0,2	0,2	0,2	38	19	50
Bi ₂ GeO ₁₀	23	3,2	0	0,99	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—

* K_c, K_i — коэф. эл.-механ. связи для продольных и поперечных упругих волн, распространяющихся в кристалле; ** $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м; для величин указывают на анизотропию.

ционные эффекты в полупроводниках, М., 1972; Физическая акустика, под ред. У. Мавона, Р. Терстона, пер. с англ., т. 7, М., 1974, гл. 5.

ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИК — пьезоэлектрические материалы, обладающие полупроводниковыми свойствами. К П. относятся полупроводники, деформирование к-рых сопровождается возникновением электрич. поля (электрич. поляризация), пропорционального величине деформации (прямой пьезоэлектрич. эффект). Под действием электрич. поля в П. возникают внутр. механ. напряжения, пропорциональные электрич. полю E (обратный пьезоэлектрич. эффект) (см. Пьезоэлектрики).

П. являются представители разл. групп полупроводниковых материалов. К ним относятся элементарные полупроводники (Te, Se), соединения группы АІІВ (GaAs, GaP, InSb и др.), группы АІІВІ (GdS, ZnO, ZnS и др.). Пьезоэлектрич. свойствами обладают SiC, соединения группы АІВВІ (GeTe, SnTe и др.), к-рые одновременно характеризуются и сегнетоэлектрич. свойствами (см. Сегнетоэлектрики). К П. могут быть отнесены также высокоомные пьезоэлектрич. материалы с примесной проводимостью, напр. группа германосилликатов (Bi₁₂GeO₂₀). Кристаллы этой группы обладают собств. фотопроводимостью, могут быть легированы разл. примесями; их примесная проводимость $\sigma \sim 10^{-8} - 10^{-7}$ Ом⁻¹·см⁻¹.

В табл. для нек-рых П. приведены пьезоэлектрич. коэф. (пьезомодули) $\epsilon_{11}, \epsilon_{12}, \epsilon_{13}, \epsilon_{22}, \epsilon_{23}$, ширина запрещенной зоны E_g и диэлектрич. проницаемость ϵ . Важной характеристикой П. является коэф. эл.-механ. связи K . Величина K^2 показывает, какая доля энергии упругой деформации (электрич. энергии) может превратиться в электрич. энергию (энергию упругой деформации) за счёт пьезоэлектрич. взаимодействия. Коэф. эл.-механ. связи зависит от направления электрич. поля, от возбуждаемой упругой моды и сильно меняются от кристалла к кристаллу.

Распространение акустич. волн в П. сопровождается возникновением электрич. полей, с к-рыми могут взаимодействовать свободные носители заряда. Это имеет место как для тепловых фононов, так и для когерентных УЗ-волн, вводимых в кристалл на входе. В последнем случае наблюдаются эффекты, обусловленные акустоэлектронным взаимодействием. К наиб. важным из них относятся акустоэлектрический эффект и усиление УЗ-волн дрейфом свободных носителей заряда. Акустоэлектрич. эффект представляет собой возникновение пост. электрич. тока или эдс в П. при распространении в нём бегущей УЗ-волны. Этот эффект связан с пространств. группировкой свободных электронов (дырок) в электрич. полях УЗ-волны, с увеличением их волной s и с передачей импульса от волны к электронам (см. Усиление электронов фононами). Плотность акустоэлектрич. тока $j = \alpha n / v$, где α — коэф. электронного поглощения, n — плотность электронов, v — интенсивность УЗ-волны; s — скорость звука. В равновкутой цепи возникает акустоэдс $U = j/\sigma$ (σ — электропроводность П.). В П.

с большой константой эл.-механ. связи акустоэдс при $l \sim 1$ Вт/см² может достигать неск. единиц В/см. Если к П. приложено пост. электрич. поле E , в к-ром скорость дрейфа электронов $v_{др} = \mu E > v_s$, то происходит усиление УЗ-волны. Коэф. усиления пропорционален K^2 и зависит от соотношения частоты УЗ, т. е. максимальной частоты $\omega_s = v_s/l$ и диффузионной частоты $\omega_d = s^2/D$, где D — коэф. диффузии. В области частот $\omega/2\pi = 100 - 500$ МГц коэф. усиления может достигать 100 дБ/см.

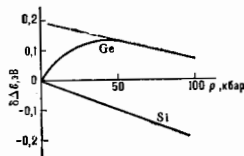
Высокоомные П. применяются в качестве пьезоэлектрических преобразователей для генерации и приёма УЗ, в ультразвуковой дефектоскопии, в акустических линиях задержки, акустооптич. устройствах (см. Акустооптика). Использование акустоэлектронного взаимодействия в П. позволяет создавать усилители УЗ-волн, фазорасщепители и преобразователи частоты, устройства аналоговой обработки радиосигналов (фильтры свёртки, корреляции и др.).

Лит.: Гуревич В. Л., Теория акустических свойств пьезоэлектрических полупроводников, ФТЛП, 1968, т. 2, в. 11, с. 1557; Усатов Я. В. И., Взаимодействие аэлектронных потоков с упругими волнами решетки, УФН, 1969, т. 97, в. 2, с. 257; Тае в е р Д. Ж., Р е й н о л д с В. Л., Т е й л о р е в ф и з и к е твердого тела, пер. с англ., М., 1975; Г а з а р е в и ч Ю. М., Г у р е в и ч В. Л., Акустоэлектроника полупроводников и металлов, М., 1978. В. В. Леманов.

ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ — электроакустич. преобразователи, действие к-рых основано на свойствах обеднённого носителями заряда тонкого слоя пьезополюпроводника. Обычно П. п. являются вибраторами, работающими на резонансной частоте (в диапазоне частот от 10 МГц до 75 ГГц). Используются пьезополюпроводники CdS, ZnO, CdSe, GaAs, AlN, GaP, ZnS и Se. Кристалл пьезополюпроводника, в к-ром формируют обеднённый слой, служит акусопроводом. Благодаря тому, что изменение электропроводности обеднённого полупроводника не вызывает заметного изменения его акустич. параметров, создаётся возможность получения интегральной структуры, объединяющей тонкий высокоомный обеднённый слой пьезополюпроводника и низкоомный звукопровод. Электрич. ВЧ-напряжение, приложенное к такой структуре, почти полностью падает на высокоомном слое, а сам слой работает как пьезопластика (см. Пьезоэлектрические преобразователи). Обеднённый слой может быть создан разл. способами (диффузией примеси, нанесением плёнок, образованием запорного слоя).

П. п. характеризуются большой шириной частотной полосы пропускания, превышающей в отд. случаях 100% от резонансной частоты. Эффективность работы П. п. определяется в осн. электрич. потерями, связанными с наличием электрич. проводимости пьезополюпроводников, и потерями, обусловленными отражением волновых полей от П. п. Используются П. п. и в пассивных и активных УЗ-линиях задержки, в пьезоэлектрич. усилителях, фидлтрах, а также при исследовании распространения *электронной звуковой волны* в веществе, в частности в исследовании электрон-фононного взаимодействия.

Лит.: Физическая акустика, под ред. У. Мэсона, пер. с англ., т. 1, Ч. Б. М., 1967; Пьезоупругие свойства преобразователи и их применение, М., 1973. Е. И. Грыцко. **ПЬЕЗОСПЕКТРОСКОПИЯ** — прецизионный метод исследования зависимости свойств твёрдых тел от внеш. давления методами оптич. спектроскопии. Особенно эффективна П. для изучения электронных свойств *полупроводников*, зависящих от их зонной структуры, в частности от ширины запрещённой зоны ϵ_g . Т. к. ϵ_g зависит от межатоомного расстояния (межатоомной связи), то с увеличением давления p можно было бы ожидать роста ϵ_g . Оказалось, что в *прямоугольных полупроводниках* ϵ_g действительно обычно растёт (исключение — Те и халькогениды Pb). В кристаллах с нек. минимумами ф-ции $\epsilon(p)$ в зоне проводимости (ϵ^- — энергия электрона, p^- — его импульс) для одних минимумов ϵ_g растёт, для других — убывает. Напр., при увеличении давления ϵ_g в Ge увеличивается с градиентом $7,5 \cdot 10^{-3}$ эВ/кбар (в InSb и GaAs — $12 \cdot 10^{-3}$ эВ/кбар), но при $p \geq 50$ кбар X-минимум зоны проводимости становится ниже L-минимума, что означает уменьшение ϵ_g с ростом давления (рис.). Т. о.,



Изменение ширины запрещённой зоны ϵ_g в зависимости от давления для Si и Ge.

отрицат. значение $\Delta \epsilon_g$ означает, что величину ϵ_g начинают определять др. минимум, чем при нормальном давлении.

Теория, описывающая влияние давления на электронный спектр, построена для ковалентных и ионных кристаллов. Отражение и поглощение света в полупроводнике (а также *фотопроводимости*) определяются зависимостью диэлектрич. проницаемости от частоты ω (см. *Диэлектрики*). Действительная ϵ' и мнимая ϵ'' части ф-ции $\epsilon(\omega)$ связаны с коэф. поглощения α и преломления n следующими соотношениями

$$\alpha^2 = \mu[-\epsilon'' + (\epsilon'^2 + \epsilon''^2)^{1/2}] / 2,$$

$$n^2 = \mu[\epsilon' + (\epsilon'^2 + \epsilon''^2)^{1/2}] / 2$$

(μ — магн. проницаемость). Зависимость $\epsilon(\omega)$ определяется электронами и ионами кристалла. Электронная часть диэлектрич. проницаемости $\epsilon_0(\omega) = \epsilon_0(\omega) + i\epsilon_0''(\omega)$. В случае, когда энергия светового кванта $\hbar\omega$ превышает ширину запрещённой зоны ϵ_g полупроводника, $\epsilon_0'(\omega)$, определяемое *Крамерса—Кронига соотношением*, меняется с давлением незначительно, а изменения ϵ_0'' даются ф-лой

$$\epsilon_0''(\omega) = \frac{2^2 \pi^2 e^2}{m^2 \omega^2} |\mathbf{eP}|^2 \frac{(M_1 M_2 M_3)^{1/2}}{n} (\hbar\omega - \epsilon_g)^{-1/2}.$$

Здесь m — масса электрона, M_1, M_2, M_3 — гл. компоненты тензора приведённой массы $\hat{M} = (m_0^{-1} + m_{\alpha}^{-1})^{-1}$, m_0, m_{α} — гл. компоненты тензора *эффективной массы* электрона и дырки, e — заряд электрона, \mathbf{P} — вектор поляризации света, \mathbf{e} — матричные элементы операторов импульса электронов (дырок). Множитель $(\hbar\omega - \epsilon_g)^{-1/2}$ отражает зависимость *плотности состояний* в зоне проводимости (валентной зоне) от энергии кванта. Матричные элементы ϵ слабо зависят от давления (как и постоянная решётки). Незначительно меняются и эфф. массы носителей, т. е. M . Осн. влияние давления связано со сдвигом электронных уровней, определяющих плотность состояний. Давление позволяет не только сдвигать электронные уровни, но и изменять электронный спектр.

По спектральной зависимости коэф. поглощения света $\alpha_0(\omega) \sim \epsilon''(\omega)$ можно определить ϵ_g в исходном и деформированном кристаллах; ϵ_g изменяется с ростом давления примерно на $\pm 10^{-3} - 10^{-2}$ эВ/кбар.

Выход ионов в ф-цию $\epsilon(\omega)$ слабо зависит от давления. Изменения ϵ_m отражают в осн. изменения фонового спектра с давлением. В случае ковалентных кристаллов частоты оптич. продольных LO- и поперечных TO-колебаний решётки растут с давлением, а частоты акустич. LA- и TA-колебаний падают (см. *Колесания кристаллической решётки*). Изменение межатоомного расстояния под действием давления меняет конфигурацию электронной оболочки ковалентных атомов, поэтому меняется и эфф. заряд ионов (знак замещения возможен любой).

Все вышеперечисленные эффекты проявляются при однородном гидростатич. давлении. В то время как оно не меняет симметрию решётки, одноосное напряжение понижает симметрию системы и поэтому приводит к расщеплению первоначально вырожденных уровней. Новый тип симметрии кристалла зависит от направления, в к-ром приложено напряжение.

Одноосное напряжение изменяет симметрию зоны Бриллюэна. Поскольку нек-рые точки k в зоне становятся при этом неэквивалентными, приложении одноосного напряжения приводит к дополнит. расщеплению уровней. Это детально проверено при исследовании пьезопоглощения света у края межзонаного перехода и визоотражения в др. критич. точках. Имевто так была подтверждена интерпретация края поглощения в Ge и Si, где минимум зоны проводимости расположен в точке L и на осн Δ .

Метод П. эффективен при изучении симметрии примесных и экзитонных состояний. В случае мелких примесей или слабосвязанных экзитонов прежде всего существенно влияние напряжения на структуру энергетич. зон. Затем устанавливаются, как это сказывается на связанных состояниях, происходящих от разл. критич. точек. У глубоких примесей энергия связи зависит больше от конфигурации ближайших атомов и ионов, чем от сдвигов зон. Поэтому влияние одноосного напряжения на примесные уровни тем сильнее, чем глубже потенциал примеси и чем больше локализованы волновые ф-ции.

Лит.: Ансельм А. И., Введение в теорию полупроводников, 2 изд., М., 1978; Бир Г. Л., Пикус Г. Е., Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, М., 1972; Martin R. G., Optical properties of semiconductors under pressure, в кн.: Handbook of semiconductors, т. 2 — Optical properties of solids, Amst.—[a. o.], 1980; Sharma H. P., Shanker J., Verma M. P., Effect of hydrostatic pressure on the electronic dielectric constant of ionic crystals, «Phil. Mag.», 1976, в. 34, р. 183; Wolden H., Martin R. M., Charge density and structural properties of covalent semiconductors, «Phys. Rev. Lett.», 1978, в. 40, р. 950. C. E. Esmont.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКИ — вещества, в к-рых при определенных упругих деформациях (напряжениях) возникает электрич. поляризация даже в отсутствие электрич. поля (прямой пьезоэффект). Следствием прямого пьезоэффекта является обратный пьезоэффект — появление механич. деформаций под действием электрич. поля. Проявления прямого и обратного пьезоэффектов могут быть различными, черным может выразаться, напр., в появлении при деформации электрич. поля в отсутствие поляризации, второй — в возникновении при наложении электрич. поля упругих напряжений в отсутствие деформаций. В общем виде речь идет о линейной связи между механич. и электрич. переменными (первые — деформация ϵ , напряжение σ ; вторые — поляризация P ,

Полупроводник	ϵ_g , эВ/бар
Si	5,2
Ge	13
GaSb	14,7
GaAs	15,5
InSb	10
InAs	6
ZnS, ZnSe	10
CdS	6,9
CdSe	6
GaS	-2
GaSe	-5
InSe	-3,5

электрич. поле E , электрич. индукция D ; см. *Диэлектрик*). Первое подробное исследование пьезоэффектов проведено Ж. и П. Кюри (J. et P. Curie) (1880) на кристалле кварца. В дальнейшем пьезоэлектрич. свойства были обнаружены более чем у 1500 веществ.

Пьезоэффекты наблюдаются только в кристаллах, не имеющих центра симметрии. (В кристаллах, обладающих центром симметрии, пьезоэффект невозможен.) Наличие др. элементов симметрии (оси, плоскости симметрии; см. *Симметрия кристаллов*) может запрещать появление поляризации в некоторых направлениях или при деформациях, т. е. также ограничивает число кристаллов — П. В результате П. могут принадлежать лишь к 20 точечным группам симметрии (из 32): 1, 2, 3, 4, 6, m , $2m$, $3m$, $4mm$, $6mm$, 222 , 4 , 422 , $42m$, $6, 622$, $6m2$, 32 , 23 , $m3$. Кристаллы первых 10 классов — *пьезоэлектрики*, т. е. обладают поляризацией в отсутствие внеш. воздействий. В этих кристаллах пьезоэффект проявляется, в частности, в изменении величины спонтанной поляризации при механич. деформации. Пьезоэлектрич. свойства можно создавать в некристаллических диэлектриках за счёт образования в них т. н. пьезоэлектрич. текстур, напр. поляризации в электрич. поле (пьеоцерамка), механич. обработкой (древесина) и др. (см. *Пьезоэлектрические материалы*).

Количеств. характеристикой пьезоэффектов в кристалле является совокупность пьезокоэффициентов (пьезомодулей) — коэф. пропорциональности между электрич. и механич. величинами. При этом одна электрич. величина (напр., E) зависит как от др. электрич. величин (напр., E), так и от механич. величин (или от σ). Напр.: поляризация, возникающая в П. под действием деформации (σ) $P = \epsilon$, где ϵ — пьезомодуль. Полная поляризация с учётом электрич. поля E выражается соотношением

$$P = \epsilon u + \chi^* E.$$

Величина χ^* имеет смысл *диэлектрической восприимчивости* при постоянной деформации. Т. к. механич. деформации могут быть представлены как совокупность 6 независимых величин (сжатия и растяжения вдоль 3 осей, а также сдвиги в плоскостях, перпендикулярных осям), а вектор поляризации P имеет 3 компонента, то в наём. симметричных кристаллах может быть 18 разных пьезокоэффициентов.

Симметрия кристалла ограничивает число независимых пьезомодулей, напр. кристалл точечной группы симметрии 422 имеет только одну независимую пьезокоэффициент. Пьезокоэффициентами являются также величины d , a , b , λ , s в соотношениях

$$P = da + \chi E, \quad \sigma = -aP + \lambda u, \quad u = -bP + \alpha \epsilon$$

и т. п. Все пьезокоэффициенты связаны друг с другом, так что при описании пьезоэлектрич. свойств можно ограничиться только одной совокупностью констант, напр. e .

Величины пьезокоэффициентов различаются для кристаллов разных типов. Для *ионных кристаллов* порядок величины пьезокоэффициента можно оценить след. образом: пусть при деформации закороченного кристалла ($E = 0$) изменение постоянной решётки (l) равно Δl , так что деформация $\epsilon = l + \Delta l/l$. Разномённые ионы сдвигаются друг относительно друга на величину $\sim \Delta l$, а поляризация $P \approx q \Delta l/l^3$, где q — заряд иона (можно считать равным заряду электрона). Т. о., порядок пьезоэлектрич. константы такой же, как и у атомного электрич. поля $E_0 \sim 10^7$ единиц ГСЭС. Существование больших величин может достигаться пьезокоэффициентами у *сенсезоэлектриков*, т. к. их поляризация может быть связана с перестройкой доменной структуры при механич. деформации.

Наличие пьезоэффектов сказывается на характере разл. акустич. явлений. Так, одна из объёмных упру-

гих волн становится поперечной (Гуляева — Блюштейна волна). Отражение и пропускание упругой волны на границе П. и др. среды могут определяться не только соотношением модулей упругости сред, но и тем, является ли др. среда диэлектриком или проводником. Коэф. усиления звука за счёт дрейфа носителей заряда в полупроводнике имеет разную зависимость от частоты звука в П. и в центросимметричных кристаллах.

П. используются в технике в качестве преобразователей механич. колебаний в электрические и электрических — в механические. Они являются осн. материалами *акустозлектроники*.

Лит.: Глазков Д. П., Диффиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Найдя Дж., Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц, пер. с англ., 2 изд., М., 1967; Сиروتни Ю. И., Шасюльска Я. М. П., Основы кристаллофизики, 2 изд., М., 1978; Таганцев А. К., Пропр., пьезо-, флюксостриктрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах, «УФН», 1987, т. 152, в. 3, с. 423.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ — вещества (диэлектрики, полупроводники), обладающие хорошо выраженными пьезоэлектрич. свойствами (см. *Пьезоэлектрики*).

Пьезоэлектрич. кристаллы распространены в природе в виде естеств. минералов (кварц, турмалин, цинковая обманка и др.), большинство практически важных П. м. синтезируют (сегнетова соль, ниобат лития, пьезоцерамка, пьезополимеры).

П. м. используются для изготовления *пьезоэлектрических преобразователей* разл. назначения: в гидролокации, УЗ-технике (см. *Ультразвук*), *акустозлектронике*, точной механике и др. Для изготовления пьезоэлемента выбирают П. м., сопоставляя их параметры и характеристики, к-рые определяют эффективность и стабильность работы пьезоэлектрич. преобразователя с учётом его назначения и условий эксплуатации. П. м. характеризуются след. величинами (табл.): матрицами пьезомодулей d и относительной диэлектрич. проницаемостью ϵ^* , коэф. упругой податливости SE , скоростью распространения звуковых волн c , тангенсом угла диэлектрич. потерь $\text{tg} \delta$, механич. добротностью Q_m , плотностью ρ , предельно допустимой темп-рой θ (темп-ра Кюри для сегнетоэлектриков). Во мн. случаях оценивать П. м. удобнее след. параметрами: 1) коэф. ал.-механич. связи K_{ik} (для квазиизотроп. режима, когда длина звуковой волны существенно превосходит размеры пьезоэлемента):

$$K_{ik} = \frac{d_{ik}}{\sqrt{\epsilon_{ii}^* \epsilon_0 S_{kk}'}}$$

где $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — диэлектрич. постоянная вакуума; 2) величиной $(d_{ik}/S_{kk}')^2$, важной для излучателей звука; 3) величиной $K_{ik}^2/\text{tg} \delta$, к-рая входит в выражение ал.-механич. кид преобразователей; 4) отношением d_{ik}/e_{ii}^* , характеризующим чувствительность *приёмника звука* в режиме холостого хода; 5) величиной $d_{ik}/\sqrt{\epsilon_{ii}^*}$, определяющей мин. сигнал, к-рый может быть принят приёмником на фоне электрич. шумов схемы; 6) механич. добротностью Q_m , определяющей акустомеханич. кид излучателя при заданной нагрузке, полосу частот пропускания ал.-механич. фильтров, качество линий задержки.

Большое значение для мощных излучателей звука имеют предельно допустимое механич. напряжение, к-рое зависит от механич. прочности материала, стабильность свойств относительно разогрева, а также нелинейность свойств, при к-рой происходит перекачка энергии в высшие гармоника и уменьшение эффективности (кид) на осн. частоте (рис. 1 и 2).

Кристаллы кварца, несмотря на их сравнительно слабые пьезоэлектрич. свойства, применяются в тех

Основные характеристики пьезоэлектрических материалов

Пьезоэлектрик	Плотность ρ , 10^3 кг/м ³	Скорость звука c_{11} , 10^3 м/с	Диэлектрич. проницаемость, ϵ	S , 10^{-12} м ² /Н	Пьезомодуль d_{31} , 10^{-12} Кл/Н	t_{30} , 10^3	Механическая добротность, Q_m	Коэффициент элентрорезонансной связи, K_{12}	Примечание
Кварц	2,6	5,47 ⁽¹¹⁾	4,5 ⁽¹¹⁾	12,77 ⁽¹¹⁾	2,31 ⁽¹¹⁾	<0,5	>10 ⁴	0,095	Срез 0° к оси X Срез 45° к оси Z
Дигидрофосфат аммония	1,8	3,25 ⁽²²⁾	15,3	52,6 ⁽²²⁾	24,0 ⁽²²⁾	<1	>10 ³	0,28	
Сульфат лития	2,05	4,7 ⁽²²⁾	19,3 ⁽²²⁾	22,5 ⁽²²⁾	16,3 ⁽²²⁾	>1	>10 ²	0,30	Срез 0° к оси Y Срез 45° к оси X; при T=55°C расширяется на химическое составление
Сегнетова соль	1,77	3,1 ⁽²²⁾	350 ⁽¹¹⁾	37 ⁽²²⁾	275	>5	—	0,65	
Сульфид лития	5,2	1,5 ⁽²²⁾	2200 ⁽²²⁾	86 ⁽²²⁾	150 ⁽²²⁾	5-10	50	0,8 ⁽²²⁾	Поляризован по оси Z
ХГС-2	5,3	1,8	900	9,2 ⁽²²⁾	1300 ⁽²²⁾	5	20	0,7 ⁽²²⁾	
Ниобат лития	4,64	5,8 ⁽²²⁾	28,6 ⁽²²⁾	5,0 ⁽²²⁾	600 ⁽²²⁾	—	<10 ⁴	0,24 ⁽²²⁾	
			84,6 ⁽²²⁾	5,8 ⁽²²⁾	17,1 ⁽²²⁾	18,2 ⁽²²⁾		17,1 ⁽²²⁾	
Пьезокерамика									
Титанат бария ТВ-1	5,3	4,6	1500	8,9	45	2	400	0,2	Пьезоэлементы поляризованы вдоль оси Z (оси 3)
Титанат бария-налция ТВК-3	5,4	4,2	1180	10,7	100	1,3	450	0,5	
		4,7		9,5	113			0,17	
Группа титаната-ниобата свинца на PZT (ЦТС) ЦТС-19	7,45	3,6	1725	10,4	100	3,5	50	0,24	
ЦТБС-3	7,2	3,0	2325	14,9	200	1,2	350	0,44	
		3,5		11,5	158			0,33	
ЦТСНВ-1	7,3	3,2	2325	13,8	>350	1,9	70	0,84	
		2,9		16,3	205			0,27	
PZT-8	7,6	2,6	1000	20,9	>445	0,4	1000	0,69	
		3,4		11,4	93			0,3	
PZT-5Н	7,5	3,1	3400	13,7	218	2,0	65	0,64	
		2,8		17,0	274			0,39	
PZT-4	7,5	2,5	1300	21,3	593	0,5	500	0,75	
		3,3		12,3	123			0,33	
		2,9		15,4	289			0,70	
Пьезополимерная плёнка									
ПВДФ	1,8	1,4-1,9	12	280	20	1	—	10	$d_{31} = 10 \cdot 10^{-12}$ Кл/м
					25				
Пьезокомпазит									
30% PbTiO ₃	3,0	1,8	20	90	—	5	—	—	$d_{31} = 12 \cdot 10^{-12}$ Кл/м

Примечание. Значения всех констант даны для темп-ры 18-20° С. Цифры в скобках у монокристаллов определяют индексы соответствующих тензорных характеристик, напр. (11) означает c_{11} , ϵ_{11} , d_{31} , (36/2)- $1/2d_{31}$, и т. д. Для пьезокерамики верх. значения (над чертой) для S и S имеют индексы (11), а для d и K — индексы (31); ниж. значения (под чертой) констант имеют индекс (33). Величины $d_{31} < 0$; $d_{32} > 0$. Значения t_{30} для кристаллов даны при напряжённости поля $E < 0,05$ кВ/см; для пьезокерамики t_{30} даны в интервале $0,05 < E < 2$ кВ/см; d_V — объёмный пьезомодуль.

случаях, когда требуются высокая механич. добротность и стабильность по отношению к изменению темп-ры (напр., в эл.-механич. фильтрах и различных стабилизирующих устройствах). Кристаллы АРР, сульфата лития и сегнетовой соли, как П. м. для излучателей и приёмников звука, вытеснены пьезокерамикой ввиду её высокой пьезоэлектрич. эффективности.

стабильности и технологичности. Сегнетополупроводники сульфонид лития и выполненный на его основе материал ХГС-2 перспективны для гидроакустич. приёмников звука.

Свойства пьезокерамики, особенно у составов типа ЦТС, с изменением темп-ры варьируют незначительно. Изменение резонаншной частоты в интервале темп-

Рис. 1. Зависимость тангенса диэлектрических потерь $\tan \delta$ от эффективного значения возбуждающего электрического поля для различных типов пьезокерамики.

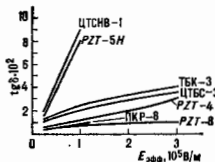
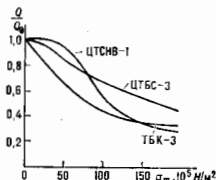


Рис. 2. Зависимость механической добротности Q_m (относительной) от амплитуды механического напряжения для различных типов пьезокерамики.



30–40°C достигает 1,5–2,0% (у сегнетовой соли до 46%), пьезомодуля и диэлектрич. проницаемости — 10–20%. Зависимость параметров пьезокерамики от эсоторного сжатия слаба, однако при действии одностороннего сжатия (10^8 Н/м²) вдоль оси спонтанной поляризации изменение (уменьшение) пьезомодулей может достигать 30–70%, а увеличение диэлектрич. проницаемости от 5 до 60%.

Кристаллы нобилата лития, тавталата лития, германата свинца применяются в УЗ-технике в области СВЧ-диапазона (плотность до ГГц) и в акустоэлектронике благодаря чрезвычайно малому затуханию в плх акустич. волн, как объёмных и сдвиговых, так и поверхностных.

Они используются в акустооптике. Для пьезопроводниковых преобразователей в микшх *задержки* и др. устройствах акустоэлектроники используются сульфид кадмия, оксид цинка, арсенид галлия и др. пьезопроводников.

Пьезополимерам относят как поливинилпидефторид (ПВДФ) и сополимеры на его основе, так и пьезоэлектрич. *композиционные материалы* (пьезокомпозиты). Материалы на основе ПВДФ выпускаются в виде плёнок толщиной от 10 мкм до 1 мм и более, металлizadosанных и полиаризованных по толщине. Пьезокомпозит может иметь структуру в виде пористого *каркаса* пьезокерамики, пропитанного полимером, или *чаще* в виде частич пьезокерамики (порошка, тонких стержней), распределённых в полимере. П. м. на основе полимеров обладают высокой пьезоэлектрич. эффективностью, эластичностью и рядом техолог. преимуществ.

Пьезоэффект в полимерах возникает в результате неупорядоченого распределения зарядов, при статич. электризации, полимеризации и др. (тип I), а также вследствие ориентации диполей в полярных полимерах при механич. деформировании (тип II), в биополимерах (тип III), при поляризации в электрич. поле (тип IV, элеттеты), в результате спонтанной поляризации в таких высокополяриых поликристаллич. полимерах (тип V), как, напр., ПВДФ, полиамиды, сегнетоэлектрич. стёкла и др.

В полимерах типа I и II пьезоэлектрич. коэф. *d* обычно невелики [$d_{33} = (0,1–0,5) \cdot 10^{-12}$ Кл·Н⁻¹]; в материалах типа III и IV они достигают более высоких значений [до $d_{33} = (1–2) \cdot 10^{-12}$ Кл·Н⁻¹]; в материалах типа V — [до $d_{33} = 40 \cdot 10^{-12}$ Кл·Н⁻¹].

Среди пьезокомпозитов наиб. распространены материалы на основе порошка титаната свинца, распределённого в полимере, т.з-за значит. величины объёмного пьезомодуля ($d_V = 30 \cdot 10^{-12}$ Кл/Н) при достаточно простой технологии изготовления.

Лит.: Матаушек И. Ультразвуковая техника, пер. с нем., М., 1962; Физическая акустика, под ред. У. Мэсона, пер. с англ., т. 1, ч. А, М., 1964; Смирнов С. И., Ф. Г. Фельдман Н. Б., Пьезоэлектрическая керамика, пер. с англ., М., 1971; Ультразвуковые преобразователи, пер. с англ., М., 1972; И. Ф. Ф. Е. К. у. У. И. Ф. Ф. Г. Пьезоэлектрические керамики, пер. с англ., М., 1974; Н. С. И. П. Л. Е. и др. Connectivity and piezoelectric—pyroelectric composites, «Mat. Res. Bull.», 1978, v. 13, № 5, p. 525; Powers J. M., An emerging hydrophone technology, «IEEE Trans. Acoust. Speech, 1979, v. 27, № 7, p. 714; R. U., Evaluation of new piezoelectric composites for hydrophone, «Ferroelectrics», 1986, v. 87; Монюге Д.-Л., Blum J. B., Safari A., Sol-gel derived P(VDF) — polymer piezoelectric composites, «Ferroelectrics. Lett. section», 1986, v. 5, p. 93.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ — электромеханич. или *электроакустический преобразователь*, действие к-рого основано на пьезоэлектрич. эффекте (см. Пьезоэлектрики). Осн. часть П. п. состоит из отдельных или объединённых в группы, электрически и механически связанных друг с другом пьезоэлементов, т. е. изготовленных из пьезоэлектрика деталей простой геом. формы (стержень, пластинка, диск и т. п.) с нанесёнными на их поверхности электродами.

П. п. применяются в разл. областях техники (УЗ-технологии и дефектоскопии, гидроакустики, радиовещания, виброметрии, акустоэлектронике) в качестве излучателей и приёмников УЗ, элементов *гидроакусти-*

ческих антенн, микрофонов и гидрофонов, пьезоэлектрич. трансформаторов, резонаторов, фильтров и др. Соответственно этому весьма широк диапазон рабочих частот П. п. — от единиц Гц в сейсмич. исследованиях до ГГц в акустоэлектронике. В зависимости от назначения и диапазона рабочих частот в П. п. используются разл. пьезоэлектрики. Наиб. широкое распространение в УЗ-технике и гидроакустике получили П. п. из пьезокерамики, в акустоэлектронике — пьезоэлектрич. и пьезополупроводниковые монокристаллы, П. п. Пьезоэлектрич. преобразователи — излучатели, вибраторы, пьезорезонаторы — используются в узком диапазоне частот *вблизи резонанса* их механич. системы, а П. п. — приёмники — как на резонанс, так и в широком диапазоне частот *вне резонанса*. В зависимости от диапазона частот, назначения и условий работы применяются П. п. разл. типов. В области высоких частот (> 100 кГц) преим. используют П. п. в виде облобочек и пластин, совершающих колебания по толщине, на частотах выше 10 МГц и в диапазоне ГГц — стержни, совершающие продольные колебания. В качестве излучателей и приёмников звука часто применяют П. п. в виде пьезокерамич. цилиндров с использованием поперечного и продольного пьезоэффекта. В области частот ниже 5–10 кГц используют П. п. в виде биморфных пластин, совершающих поперечные изгибные или крутильные колебания. Свойства таких П. п. существенно зависят от условий закрепления пластин. П. п. в виде полых пьезокерамич. сфер применяются как широкополосные, ненаправленные гидрофоны. Используются также т. н. пьезокомпозиты и пьезополимеры (гл. обр. для приёмников звука).

Расчёт П. п. имеет целью установить связь между величинами электрическими (напряжение на электродах *U*, ток через преобразователь *I*) и механическими (приложенная к механич. системе сила *F*, смещение ξ или колеб. скорость v_m). При расчётах П. п. может быть замещён эл.-механич. схемой, эквивалентной ему с точки зрения расчёта соотношения между элеттрич. и механич. (акустич.) величинами.

Кид П. п. существенно зависит от величины сопротивления нагрузки r_n , на к-рую работает излучающий преобразователь, и от величины механического r_m и электрического *R* сопротивлений преобразователя. Кид П. п. может достигать 40–70%. Макс. мощность, к-рую может развивать П. п., ограничивается величинами допустимых напряжённостей элеттрич. поля и механич. динамич. напряжений в П. п., а также его разогревом.

Лит.: Матаушек И. Ультразвуковая техника, пер. с нем., М., 1962; Физическая акустика, под ред. У. Мэсона, пер. с англ., т. 1, ч. А, М., 1966; Ультразвуковые преобразователи, пер. с англ., М., 1972; Г. у. т. и Л. Я., Изобр. труды, Л., 1977; Справочник по гидроакустике, Л., 1982.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР — пьезоэлектрический преобразователь с ярко выраженными резонансными свойствами *вблизи собств. частот* колебаний механич. системы (см. также Резонанс). Представление П. р. в виде эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами см. на рис. 1. При внеш.

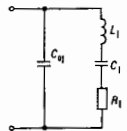


Рис. 1. Эквивалентная схема пьезоэлектрического резонатора.

возбуждающей частоте $f = f_p$ наступает механич. резонанс и ток в элеттрич. цепи П. р. достигает макс. значения. При повышении частоты до $f_a > f_p$, называе-

мой частотой антирезонанса, impedance П. р. становится максимальным, а ток в его цепи — минимальным (резонанс токов). Величину $\Delta f = f_a - f_p$ называют резонансным промежуток. Качество П. р. определяется остротой его частотной характеристики (рис. 2) и величиной кид. Значение частот f_p и f_a позволяет определить ряд важных характеристик П. р.,

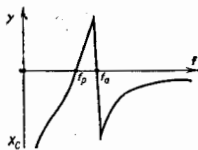


Рис. 2. Зависимость реактивного сопротивления пьезоэлектрического резонатора от частоты колебания.

и в первую очередь коэф. эл.-механич. связи $K \approx \sqrt{2\Delta f/f_p}$. Экспериментально параметры П. р. определяются методами резонанса — антирезонанса, переменной электрич. нагрузки, круговых диаграмм и др.

П. р. широко используются в радиотехнике, электронике, электроакустике и др. в качестве фильтров, резонаторов, в задающих генераторах, резонансных пьезообразователей и пьезотрансформаторов. Пьезоэлектриком в П. р. служит кристалл кварца или пьезокерамика с малыми потерями. Кварцевые резонаторы применяются в качестве резонансных контуров генераторов электрич. ВЧ-колебаний. Высокая добротность ($10^4 - 10^6$) кварцевого резонатора определяет малый уход частоты генератора от её номинального значения [$10^{-3} - 10^{-5}\%$] при изменении окружающей темп-ры, давления и влажности. Разработаны микроинанторные кварцевые резонаторы на частоты колебаний 30 кГц — 8,4 МГц, нашедшие применение в электронных часах, системах автентронного зажигания двигателей внутр. сгорания и др. П. р. на основе кварца используются в акустоэлектронных устройствах фильтрации и обработки сигналов: монолитных пьезоэлектрич. фильтрах, а также фильтрах и резонаторах на *поверхностных акустических волнах* (ПАВ). Осн. достоинство резонаторов на ПАВ — возможность использования в устройствах стабилизации частоты и узкополосной фильтрации в диапазоне частот 100—1500 МГц. Пьезоэлектрич. фильтры из пьезокерамики, как правило, многоэлементные, изготавливают на частоты 1 кГц — 10 МГц. При этом на частотах до 3,5 кГц используют биморфные пьезоэлементы, когда П. р. совершает резонансные колебания изгиба по грави; в

Параметры пьезоэлектрического резонатора

Основные параметры	Производные параметры
Емкость П. р., заторможенного по отношению к рассматриваемому резонансу C_{0p}	Емкостное отношение $\gamma = C_{0p}/C_1$
Динамич. ёмкость C_1	Механич. добротность $Q_m = \frac{\omega_0}{R_1} = \frac{1}{\omega_p C_1 R_1}$
Динамич. индуктивность L_1	Коэф. качества $K = \frac{Q_m}{\gamma} = \frac{1}{\omega_p C_0 R_1}$
	Резонансная частота $f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$
Эквивалентное сопротивление механич. потерь R_1	Частотная постоынная $N = \rho l^3 A$
	Константа динамич. ёмкости $G_1 = \frac{C_1}{A}$

Примечание. d — резонансный размер; l — расстояние между электродами; A — площадь электродов.

диапазоне 40—200 кГц применяют П. р. с продольными колебаниями по длине, а на частотах 200—800 кГц — П. р. в виде дисков, совершающих радиальные колебания. На частотах св. 1 МГц используют толщинные колебания пьезокерамич. колец. Рассматриваемые фильтры отличаются простотой конструкции, малыми (по сравнению с LC-фильтрами) габаритами и стабильными рабочими характеристиками (табл.).

Лит.: Кэйд и Уэ. Пьезоэлектричество и его практическое применение, пер. с англ., М., 1948; Пьезокерамические проб. резонатели, под ред. С. И. Пугачева, Л., 1984; Интегральные пьезоэлектрические устройства фильтрации и обработки сигналов, под ред. В. Ф. Усольцова, В. В. Дмитриева, М., 1985.

Ф. Ф. Лейва, С. И. Пивов

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО — обратная эл.-механич. связь: электрич. поляризации и механич. деформации, наблюдаемая в виде прямого и обратного пьезоэлектрич. эффектов в кристаллич. средах с определ. симметрией, см. *Пьезоэлектрики*.



РАБИ МЕТОД — метод исследования энергии структуры атомов и молекул, основанный на явлении резонансного поглощения радиочастотного поля при совпадении частоты поля с частотой *квантового перехода* в этих системах. Разработан И. Раби (I. Rabi) в 1938 для молекулярных и атомных пучков.

При помощи Р. м. впервые наблюдался ядерный магнитный резонанс в нейтральных молекулярных пучках, при этом радиочастотное магн. поле H_1 вызывало резонансную переориентацию магн. моментов молекул. Пучок молекул, выходящий из источника O , отклоняется неоднородным магн. полем (магнит A на рис.), а затем фокусируется на детектор D неоднородным полем с градиентом противоположного знака (магнит B). Поля подбирают так, чтобы молекулы попадали на детектор независимо от их скорости. В заоре магнита C , создающего однородное магн. поле H_0 , помещают проволочную петлю, соединяющую с радиочастотным генератором и создающую поле H_1 . В результате переориентации магн. моментов нарушается условие фокусировки и уменьшается число молекул, попадающих на детектор. Резонанс наблюдают по изменению интенсивности пучка на детекторе при изменении напряженности поля H_0 или частоты генератора ω .

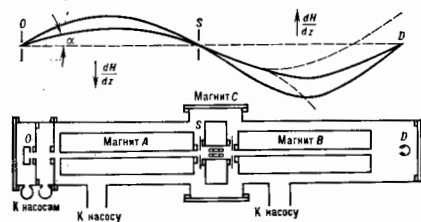
В квантовой теории переориентацию магн. моментов описывают как переход между двумя уровнями энергии молекул. Вероятность перехода под действием осциллирующего возмущения за время t равна

$$P(t) = \left(\frac{\Omega}{\omega} \sin \frac{\tilde{\omega} t}{2} \right)^2,$$

где $\Omega = \omega_0 H_1 / H_0$ — частота Раби, $\omega_0 = \gamma H_0$ — угл. частота прецессии магн. момента, γ — гиромагн. отношение, $\tilde{\omega}^2 = \Omega^2 + (\omega - \omega_0)^2$ (см., напр., *Други уровневая система*). Время t воздействия поля H_1 в молекулу равно l/v , где l — размеры области, в которой $H_1 \neq 0$, v — скорость молекулы. Вероятность $P(t)$ нужно усреднить в соответствии с распределением молекул по скоростям. Ширина резонанса по частоте обратно пропорциональна величине l/v_0 , где $v_0 = \overline{v}$ — ср. скорость молекул, но с увеличением l уменьшается интенсивность пучка.

Н. Рамзей (N. Ramsay) усовершенствовал Р. м., добившись существенного сужения резонанса. При этом пучок молекул последовательно проходит через

две области строго сфазированного радиочастотного поля, размером l каждая, к-рые размещены в пространстве на расстоянии L . При $L \gg l$ и узком распределении молекул в пучке по скоростям выходной сигнал в таком устройстве, как ф-ция ω , представляет собой не



одиночный резонанс, как в Р. м., а систему резонансов с расстоянием d между соседними максимумами ω/L . При нулевой разности фаз между осциллирующими полями в соседних областях центр максимума точно совпадает с ω_0 , а его полная ширина определяется временем пролёта молекул между областями с двумя размещёнными радиочастотными полями.

Обычно Р. м. используют в спектрометрах радиочастотного диапазона (см. *Радиоспектроскопия*). Одним из важнейших применений Р. м. является измерение магн. моментов протона, дейтрона и электрона. Р. м. лежит в основе квантовых стандартов частоты и мн. методов исследования спектральных характеристик газов, жидкостей и твёрдых тел.

Лит.: Рамзаев А. Н. Молекулярные пучки, пер. с англ., М., 1969; Физические основы квантовой радиодинамики, Л., 1985.

РАБОТА в термодинамике — способ обмена энергией между термодинамич. системой и окружающими телами при изменении внеш. параметров состояния, к-рые определяют положение границ системы или её частей и взаимодействие с внеш. силовыми полями; кол-во энергии, передаваемое этим способом. Др. способом обмена энергией, связанным с изменением энтропии, является передача теплоты. Величина Р. максимальна для квазистатич. процессов (принцип максимальной работы), в этом случае выражение для Р. δW , производимой системой при бесконечно малом изменении внеш. параметров $dx = \{dx_i\}$, записывают по аналогии с механикой в виде $\delta W = Xdx = \sum_i X_i dx_i$ (X_i — соответствующая параметру x_i обобщённая сила, характеризующая реакцию системы на квазистатич. изменение dx_i). Выражение для Р. совершаемой при конечном изменении состояния, записывают в виде интеграла

$$\Delta W = \int_1^2 \delta W = \int_1^2 \sum_i X_i dx_i.$$

Это выражение существенно зависит от того, какие значения имеют величины $X_i = X_i(T, x, N)$ в каждом из промежуточных состояний квазистатич. перехода $1 \rightarrow 2$, к-рые определяются не только набором параметров x_i , но и значениями темп-ры T (или энтропии) и чисел частиц отд. компонентов $N = \{N_i\}$. Величина ΔW зависит от пути интегрирования, а δW не является полным дифференциалом в переменных (T, x, N) , определяющих термодинамич. состояние системы. Поэтому в результате замкнутого кругового процесса можно получить отличную от нуля работу. Величина δW участвует наряду с изменением внутр. энергии dU и величиной подводимого к системе тепла,

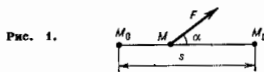
δQ в балансе, выражающем первое и второе начала термодинамики для квазистатич. процессов:

$$\delta Q = TdS = dU + \delta W - \mu dN,$$

где $\mu = \{ \mu_i \}$ — хим. потенциалы компонентов системы. Для адиабатических изолиров. системы ($dS = 0$) с фиксиров. числом частиц ($dN = 0$) выражение для δW определяется изменением внутр. энергии, (δW) = $-(dU)$, для системы с фиксиров. темп-рой — изменением её свободной энергии, (δW)_T = $-d(U - TS)$ = $-(dF)$, и т. д.

Примеры. Р. пространственно однородной системы при изменении dV её объёма равна $\delta W = pdV$ (p — давление; при падении касательных напряжений выражение для δW составляется в соответствии с правилами теории упругости). Для поверхностной плёнки $\delta W = -\sigma dS$ (σ — коэф. поверхностного натяжения, S — площадь поверхности раздела фаз). Для гальванич. элемента $\delta W = Edq$ (E — эдс элемента, dq — протекший через него заряд). Для диэлектриков используют неск. вариантов выбора параметров состояния и соответствующих им выражений для удельной Р. $\delta w = \delta W D = -(EdD)/4\pi$ — полная Р. (E — напряжённость электрич. поля, D — индукция); $\delta w_E = PdE$, $\delta w_P = -EdP$ (P — поляризация диэлектрика). Для магнетика уд. Р.: $\delta w_H = -(HdB)/4\pi$, $\delta w_M = -HdM$, $\delta w_H = MdH$ (B и M — соответственно магн. индукция и намагниченность). Приведённые варианты для δw отличаются друг от друга на величины, являющиеся полными дифференциалами (для диэлектрика это $E^2/8\pi$ и $-(EP)$), к-рые можно включить в дифференциал внутр. энергии dU , поэтому каждому из выборов x_i соответствует согласованное определение величины δw_i и dU_i .

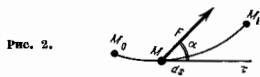
Лит.: см. при ст. Термодинамика.
РАБОТА с илы — мера действия силы, зависящая от её модуля и направления и от перемещения точки приложения силы. Если сила F постоянна по модулю и направлению, а перемещение M_0M_1 прямолинейно (рис. 1), то Р. определяется равенством $A = Fscos\alpha$, где $s = M_0M_1$, α — угол между направлениями силы



и перемещения. Если $\alpha < 90^\circ$, то $A > 0$, а если $180^\circ \geq \alpha > 90^\circ$, то $A < 0$; если же $\alpha = 90^\circ$, т. е. если сила перпендикулярна перемещению, то $A = 0$. Единицы измерения Р. — джоуль, эрг ($1 \text{ эрг} = 10^{-7} \text{ Дж}$) и килограмм-метр ($1 \text{ кгс-м} \approx 9,81 \text{ Дж}$).

В общем случае для вычисления Р. силы вводит понятие элементарной работы $dA = Fscos\alpha = F ds$, где ds — элементарное перемещение точки приложения силы, α — угол между силой и касательной к траектории её приложения, направленной в сторону перемещения точки, F_s — проекция силы на эту касательную (рис. 2). В декартовых координатах

$$dA = F_x dx + F_y dy + F_z dz, \quad (1)$$



где F_x, F_y, F_z — проекция силы на координатные оси; x, y, z — координаты точки её приложения. В обобщённых координатах

$$dA = \sum_i Q_i dq_i, \quad (2)$$

где q_1 — обобщенные координаты, Q_1 — обобщенные силы. Для сил, действующих на тело, имеющее неподвижную ось вращения z , $dA = M_z d\varphi$, где M_z — сумма моментов сил относительно оси вращения, φ — угол поворота тела. Для сил давления $dA = p dV$, где p — давление, V — объём.

Р. силы на конечном перемещении определяется как предел интегральной суммы соответствующих элементарных работ и при перемещении M_0, M_1 выражается криволинейным интегралом

$$A = \int_{M_0, M_1} (F_x \cos \alpha) ds \quad \text{или} \quad A = \int_{M_0, M_1} (F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$

Для потенциальных сил $dA = dU$ или $dA = -d\Pi$, где U — силовая функция, Π — потенциальная энергия системы, $A = U_1 - U_0$ или $A = \Pi_0 - \Pi_1$, где U_0, U_1, Π_0, Π_1 — значения соответствующих величины в начальном и конечном положениях системы; в этом случае Р. в зависит от вида траекторий точек приложения сил. При движении механич. системы сумма работ всех действующих сил на векром перемещения этой системы равна изменению её кинетической энергии T на этом же перемещении, т. е.

$$\sum A_i = T_1 - T_0.$$

Понятие Р. широко используется в механике и в др. областях физики, а также в технике. С. М. Торс.
РАБОТА ВЫХОДА — энергия, к-рая затрачивается твёрдым или жидким телом при тепловом возбуждении электрона этого тела в вакуум (в состоянии с равной нулю кинет. энергией). Р. в. равна разности двух энергий: 1) энергии покоящегося электрона, находящегося в такой точке вне тела, к-рая, с одной стороны, удалена от поверхности тела на расстояние, во много раз превышающее межатомные расстояния, а с др. стороны, гораздо ближе к рассматриваемой поверхности тела, чем к др. телам и к краю этой поверхности (в частности, эта точка должна быть далека от края рассматриваемой кристалл. грани); 2) эл.-хим. потенциала электронов в рассматриваемом теле, к-рый в состоянии термодинамич. равновесия одинаков во всех точках тела. Если эл.-статич. потенциал в вакууме в указанной точке равен $\Phi_{\text{вак}}$, в объёме тела — $\Phi_{\text{об}}$, \mathcal{E}_F — ферми-энергия электронов (уровень их хим. потенциала), $\mathcal{E}_F - e\Phi_{\text{об}}$ — эл.-хим. потенциал электронов в рассматриваемом теле, то Р. в. равна

$$\Phi = -e\Phi_{\text{вак}} - (\mathcal{E}_F - e\Phi_{\text{об}}). \quad (1)$$

Осн. часть Р. в. представляет собой энергию связи электрона в твёрдом теле с атомными ядрами и др. электронами и аналогична энергии ионизации атомов и молекул. Однако есть ещё вклад в Р. в., связанный с наличием в приповерхностной области любого тела двойного электр. слоя. Он возникает даже на идеально нравильной и чистой поверхности кристалла в результате того, что «центр тяжести» плотности электронов в приповерхностной кристаллич. ячейке не совпадает с плоскостью, в к-рой расположены яоны. При этом разность $\Phi_{\text{вак}} - \Phi_{\text{об}} = 4\lambda P_s$, где P_s — дипольный момент двойного слоя, приходящийся на единицу площади поверхности ($P_s > 0$, если дипольный момент направлен наружу). Толщина двойного слоя в металлах и аналогичного двойного слоя в полупроводниках порядка межатомных расстояний. В полупроводниках вблизи поверхности помимо этого возникает ещё двойной слой в виде области пространственного заряда, толщина к-рой может достигать тысяч межатомных расстояний.

Р. в. — характеристика поверхности тела. Грани одного и того же кристалла, образованные разными кристаллографич. плоскостями или покрытые разными

веществами, имеют разные величины Р. в. и потому разные Р. в. Потенциал $\Phi_{\text{вак}}$ этих поверхностей разный (каждый из этих потенциалов определяется в точке, близкой к соответствующей поверхности), поэтому угод поверхности возникает контактная разность потенциалов и соответствующее эл.-статич. поле.

Р. в. может быть сильно изменена адсорбцией разл. атомов или молекул на поверхности (адсорбиров. частицы изменяют величину P_s) даже в том случае, когда объёмные свойства тела неизменны. Атомы металлов с малой энергией ионизации, напр. Cs, снижают Р. в. — в нек-рых полупроводниках до величин ~ 4 эВ (см., напр., табл.).

Если на поверхности полупроводника нет поверхностных состояний (напр., поверхности (110) GaAs и InP), то при изменении уровня Ферми \mathcal{E}_F (при легировании полупроводника или изменении темп-ры) изменяется и Р. в. — в соответствии с ф-лой (1). Однако при большой плотности поверхностных состояний (как, напр., у Ge, Si) изменение \mathcal{E}_F вызывает такое изменение $\Phi_{\text{вак}} - \Phi_{\text{об}}$, к-рое компенсирует изменение \mathcal{E}_F , так что Р. в. оказывается почти постоянной к изменениям \mathcal{E}_F в объёме полупроводника.

Р. в. определяет величину и температурную зависимость тока термоэлектронной эмиссии. В зависимости от того, в каких условиях происходит эмиссия электронов — адиабатических или изотермических, с Р. в. совпадает изменение внутр. энергии или соответственно свободной энергии тела, связанное с испусканием одного электрона.

Мин. энергия, требуемая для эмиссии электрона при фотоэлектрич. эффекте, при вторичной электронной эмиссии, когда эмиссия происходит не в результате спонтанного теплового возбуждения за счёт внутр. энергии тела, а под действием внешнего источника (света, быстрого электрона), в общем случае отличается от Р. в., к-рую поэтому для определённости называют термоминимумом $\Phi_{\text{т.м.}}$ в металлах и сильно легированных (вырожденных) полупроводниках, в к-рых верх. уровень заполненных электронами состояний совпадает с \mathcal{E}_F , фотоэлектрич. Р. в. совпадает с термоэлектронной Р. в. Но в сравнительно чистых полупроводниках верхний заполненный уровень совпадает с краем валентной зоны, к-рый во мн. случаях ниже \mathcal{E}_F , вследствие чего фотоэлектрич. Р. в. больше термоэлектронной Р. в.

Р. в. измеряют по температурной зависимости и по величине термоэмиссионного тока; в металлах и вырожденных полупроводниках — по красной границе внеш. фотоэффекта. Контактная разность потенциалов U_K двух тел равна разности их Р. в.; измеряя U_K между исследуемой поверхностью и эталонной, Р. в. к-рой известна, находят Р. в. первой.

Работа выхода (в эВ) некоторых поликристаллических металлов, полупроводников и отдельных граней монокристалла вольфрама

Li	2,38	Fe	4,31	Cu	4,40	Ge	4,76	Ni(Cs)	
K	2,22	Cr	4,58	Au	4,3	Si	4,8	W (110)	1,37
Gs	1,81	Co	4,41	Ag	4,30	Ag ₂ O(Cs)		W (111)	2,3
							0,75	W (100)	4,4
Ni	4,50	Mn	3,83	W	4,54	Ta(Cs)	1,1	W (111)	4,6

Примечание. (Cs) обозначает покрытие цезием.

Лит.: Фоменко В. С., Эмиссионные свойства материалов, Справочник, 4 изд., К., 1981; Дюбрецко в Л. Н., Толмачёва и М. В., Эмиссионная электроника, М., 1966; Рильерс Р. X., Работа выхода. Измерения и результаты, в сб.: Поверхностные свойства твёрдых тел, под ред. М. Грина, пер. с англ., М., 1972. Ш. М. Ногам.

РАВНОВЕСИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ — состояние, при к-ром все точки механич. системы находятся в покое по отношению к рассматриваемой системе отсчёта. Если система отсчёта является инерциальной,

равновесие наз. абсолютным, в противном случае — относительным. Изучение условий Р. м. с. — одна из осн. задач статистики. Условия Р. м. с. имеют вид равенств, связывающих действующие силы и параметры, определяющие положение системы; число этих условий равно числу степеней свободы системы. Условия относ. Р. м. с. составляются так же, как и условия абс. равновесия, если к действующим на точки системы силам прибавить соответствующие переносные силы инерции. Необходимые и достаточные условия равновесия свободного твёрдого тела состоят в равенстве нулю сумм проекций на три координатные оси $Oxyz$ и сумм моментов относительно этих осей всех приложенных к телу сил, т. е.

$$\sum F_{kx} = 0, \quad \sum F_{ky} = 0, \quad \sum F_{kz} = 0; \\ \sum m_x F_k = 0, \quad \sum m_y F_k = 0, \quad \sum m_z F_k = 0. \quad (1)$$

При выполнении условий (1) тело будет по отношению к данной системе отсчёта находиться в покое, если скоординировать все его точки относительно этой системы в момент начала действия сил были равны нулю. В противном случае тело при выполнении условий (1) будет совершать т. н. движение по инерции, напр. двигаться поступательно, равномерно и прямолинейно, равномерно вращаться вокруг одной из своих гл. центр. осей инерции или совершать вокруг центра масс более сложное движение, в частности регулярную прецессию. Если твёрдое тело не является свободным (см. *Связи механических тел*), то условия его равновесия дают те же равенства (1) (или их следствия), к-рые не содержат реакций наложенных связей; остальные равенства дают ур-ния для определения неизвестных реакций. Напр., для тела, имеющего неподвижную ось вращения Oz , условием равновесия будет $\sum m_x F_k = 0$; остальные равенства (1) служат для определения реакций подшипников, закрепляющих ось. Если тело закреплено наложенными связями жёстко, то все равенства (1) дают ур-ния для определ. реакций связей. Такого рода задачи часто решаются в технике.

На основании *отвердевшей принципа* равенства (1), не содержащие реакций внеш. связей, дают одновременно необходимые (но недостаточные) условия равновесия любой механич. системы, в частности деформируемого тела. Необходимые и достаточные условия равновесия любой механич. системы могут быть найдены с помощью *возможных перемещений принципа*. Для системы, имеющей n степеней свободы, эти условия состоят в равенстве нулю соответствующих обобщённых сил:

$$Q_1 = 0, \quad Q_2 = 0, \dots, Q_n = 0. \quad (2)$$

Из состояний равновесия, определяемых условиями (1) и (2), практически реализуются лишь те, к-рые являются устойчивыми (см. *Устойчивость равновесия*). Равновесия жидкостей и газов рассматриваются в *гидростатике* и *аэростатике*.

С. М. Тарг.

РАВНОВЕСИЕ ПЛАЗМЫ в магнитном поле — состояние плазмы, в к-ром сила газокINETИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, действующая на любой элемент её объёма, уравновешивается силой Ампера; одно из необходимых условий магн. *удержания плазмы*. В случае скалярного (изотропного) давления плазмы $p(r)$ в пренебрежении силой тяжести условие равновесия имеет вид:

$$\operatorname{grad} p = [jB] = -\nabla(B^2/2\mu_0) + (B \nabla) B / \mu_0. \quad (*)$$

Здесь $j = \operatorname{rot} B / \mu_0$ — плотность электр. тока, B — магн. индукция, $\operatorname{div} B = 0$, μ_0 — магнитная постоянная (система единиц СИ). Ур-ние равновесия (*) накладывает существенное ограничение на форму возможной равновесной конфигурации плазмы, выражаемое

требованием $\operatorname{rot}(B \nabla) B = 0$. Напр., в частн. торондальном магн. поле $B_z \neq 0$ (т. е. при $j_z = 0$) невозможно равновесие, ограниченное вдоль оси z (осн. симметрия), т. к. в этом случае и поле и давление постоянны вдоль оси z :

$$\operatorname{rot}(B \nabla) B = -\operatorname{grad} B_z^2 / \operatorname{rot} z + \operatorname{grad} p / \operatorname{rot} z = -\operatorname{grad} (B_z^2 / 2\mu_0) / \operatorname{rot} z = 0.$$

Конфигурация магн. поля, в к-рых возможно равновесие ограниченного объёма плазмы, образуют *магнитные ловушки*. Как следует из теоремы вириала, — интегрального выражения ур-ния равновесия (*), — равновесие ограниченного объёма плазмы невозможно за счёт только магн. поля, создаваемого током в самой плазме. Напр., хотя в кольце плазмы с током благодаря *пинч-эффекту* осуществляется равновесие по малому радиусу, равновесие по большому радиусу нет и под действием эл.-динамич. сил кольцо растягивается (даже и при наличии стягивающего внутр. торондального магн. поля). Чтобы подобная кольцевая конфигурация с током и торондальным магн. полем была в равновесии, необходимо либо внешнее поперечное к плоскости кольца магн. поле, либо внеш. плазма с давлением, превышающим давление плазмы в кольце. Такого рода магн. трубки наблюдаются в фотосфере Солнца. В последнем случае следует скорее говорить не о Р. п. в магн. поле, а о равновесии магн. поля в плазме.

Р. п., описываемое ур-нием (*), реализуется при условиях, что оно устойчиво (см. *Удержание плазмы*). Лит.: Шафранов В. Д., *Равновесие плазмы в магнитном поле*, в сб.: *Вопросы теории плазмы*, в. 2, М., 1963, с. 92; Арцимович Л. А., Сагдеев Р. З., Физика плазмы для физиков, М., 1979, гл. 2, § 9; Кадомцев В. Б., *Коллективные явления в плазме*, М., 1988, гл. 1, § 3. В. Д. Шафранов. **РАВНОВЕСИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ** — состояние замкнутой статистич. системы, в к-ром ср. значения всех физ. величин и параметров, его характеризующих (напр., темп-ры и давления), не зависят от времени. Р. с. — одно из осн. понятий *статистической физики*, играющее такую же важную роль, как *равновесие термодинамическое в термодинамике*. Р. с. не является обычным равновесием в механ. смысле, т. к. в системе постоянно возникают малые флуктуации физ. величин около их ср. значений; равновесие является подвижным, или динамическим. В статистич. физике Р. с. описывают с помощью разл. *Гиббса распределений* (микроравновесия, канонич. и большого канонич. распределения) в зависимости от типа контакта системы с окружающей средой (термостатом), запрещающего или разрешающего обмен с ней энергией или частицами. Статистич. физика позволяет описать также флуктуации в состоянии Р. с.

В теории неравновесных процессов важную роль играет понятие и с о л о н о г о Р. с. (квазиравновесное состояние), при к-ром параметры системы зависят от времени (эта зависимость может быть слабой). Применяется также понятие л о к а л ь н о г о Р. с., при к-ром темп-ра и хим. потенциал в малом элементе объёма (содержащем большое число частиц и движущемся с гидродинамич. скоростью) зависят от времени и пространственных координат (см. *Локальное термодинамическое равновесие*). Это понятие служит основой для гидродинамич. описания неравновесных состояний.

Л. Н. Зубович.

РАВНОВЕСИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ — состояние термодинамич. системы, в к-рое она самопроизвольно приходит через достаточное большое промежуток времени в условиях изоляции от окружающей среды. При Р. т. в системе прекращаются все *необратимые процессы*, связанные с диссипацией энергии: теплопроводность, диффузия, хим. реакции и др. В состоянии Р. т. параметры системы не меняются со временем (строго говоря, те из параметров, к-рые не фиксируют задаваемые условия существования системы, могут испытывать флуктуации — малые колебания около своих ср. значений). Изоляция системы не исключает опреде.

типа контактов со средой (напр., теплового контакта с термостатом, обмена с ним веществом). Изоляция осуществляется обычно при помощи неподвижных стенок, непроницаемых для вещества (возможно также случаи подвижных стенок и полупроницаемых перегородок). Если стенки не проводят теплоты (как, напр., в сосуде Дьюара), то изоляция наз. адиабатической. При теплопроводящих (диатермических) стенках между системой и внеш. средой, пока не установилось Р. т., возможен теплообмен. При полупроницаемых для вещества стенках Р. т. наступает, когда в результате обмена веществом между системой и внеш. средой выравниваются хим. потенциалы среды и системы. Переход системы в Р. т. наз. релаксацией.

Одно из условий Р. т. — механич. равновесие, при котором невозможны никакие макроскопич. движения частей системы, но поступат. движение и вращения системы как целого допустимы. В отсутствие внеш. полей и вращения системы условием её механического равновесия является постоянство давления во всём объёме системы. Др. необходимые условия Р. т. — постоянство темп-ры и хим. потенциала в объёме системы, они определяют термическое и химическое равновесие системы.

Достаточные условия Р. т. (условия устойчивости) могут быть получены из второго начала термодинамики; к ним, напр., относятся: возрастание давления при уменьшении объёма (при пост. темп-ре) и положит. значение теплоёмкости при пост. давлении. В общем случае система находится в Р. т. тогда, когда термодинамич. потенциал системы, соответствующий независимым в данных условиях переменным, минимален (см. *Потенциалы термодинамические*), а энтропия — максимальна.

Лит.: Леонович М. А., Введение в термодинамику, 2 изд. М., 1952; Кубо Р., Термодинамика, пер. с англ., М., 1970; Мюллер А., Химическая термодинамика, пер. с нем., М., 1971. Д. Н. Зубарев.

РАВНОВЕСИЯ СОСТОЯНИЯ динамической системы — состояние динамической системы, к-рое не изменяется во времени. Р. с. может быть устойчивым, неустойчивым и безразлично-устойчивым. Движение системы вблизи равновесия (при малом от него отклонении) существенно различается в зависимости от характера (типа) Р. с. В случае систем с одной степенью свободы, если Р. с. устойчиво, то при малом возмущении (отклонении) система возвращается к нему, совершая затухающие колебания (на фазовой плоскости такому движению соответствует устойчивый фокус — рис. 1, а) или движется аperiodически (устойчивый узел — рис. 2, а). Вблизи неустойчивого Р. с. малые отклонения системы нарастают, при этом система совершает колебания (неустойчивый фокус — рис. 1, б) или движется аperiodически (неустойчивый узел —

рис. 1. Поведение траекторий в окрестности устойчивого (а) и неустойчивого (б) фокусов; здесь $n = 2$, $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\omega$, $\alpha < 0$ (а) и $\alpha > 0$ (б).

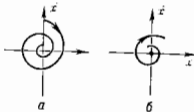


рис. 2. Траектории в окрестности устойчивого (а) и неустойчивого (б) узлов; $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$ (а), $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ (б).

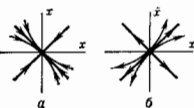


рис. 2, б); вблизи седлового Р. с. (рис. 3) возможно вынаде приближение к Р. с., а затем уход от него. Наконец, в случае безразлично-устойчивого Р. с. («центр», рис. 4) малые отклонения приводят к незату-

хающим колебаниям вблизи Р. с. Для систем с пск. степенями свободы движение системы вблизи Р. с. может быть более сложным и существенно зависит от характера начального отклонения.

рис. 3. Состояние равновесия типа «седло».

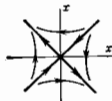
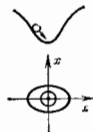


рис. 4. Замкнутые траектории в окрестности точки типа «центр».



Движение динамич. системы вблизи Р. с. чаще всего описывается линеаризов. ур-ниями, имеющими решение в виде сумм экспонент $a_i \exp(\lambda_i t)$ с комплексными (в общем случае) характеристич. показателями λ_i — корнями характеристич. ур-ния:

$$\det(A - \lambda E) = 0,$$

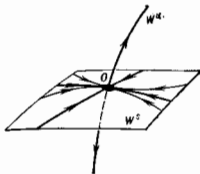
где $A = \partial X_i(x_*) / \partial x_j$, а X_i — правая часть дифференц. ур-ний, описывающих исследуемую систему:

$$dx_j/dt = X_j;$$

x_* — решение, отвечающее равновесию, $X(x_*) = 0$. Если $\text{Re} \lambda_k < 0$ ($\text{Re} \lambda_k > 0$), то Р. с. асимптотически устойчиво (неустойчиво) и через все точки в окрестности x_* проходят траектории, стремящиеся к x_* при $t \rightarrow \infty$ ($t \rightarrow -\infty$), — рис. 1.

Если $\text{Re} \lambda_k < 0$, $k = 1, \dots, m$, $\text{Re} \lambda_j > 0$, $j = m + 1, \dots, n$, то Р. с. — «седло»; траектории, стремящиеся к нему при $t \rightarrow \infty$ ($t \rightarrow -\infty$), лежат на устойчивом (неустойчивом) многообразии — многомерной сепаратрисе размерности m ($n - m$) — рис. 5.

рис. 5. «Седло» в трёхмерном фазовом пространстве; $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < 0$, $\lambda_4 > 0$; W^u — двумерное устойчивое, W^s — одномерное неустойчивое многообразия.



В консервативных (в частности, гамильтоновых) динамич. системах устойчивыми (по Ляпунову) могут быть лишь Р. с. с чисто мнимыми или нулевыми λ_k . Напр., незатухающие колебания шарика в «потенциальной яме» (рис. 4) описываются движением точки по замкнутой траектории в окрестности Р. с. типа «центр», для к-рого $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$.

Если динамич. система зависит от параметра, то (даже и в неконсервативном случае) при его изменении $\text{Re} \lambda_k$ может обратиться в нуль, и тогда Р. с. может претерпевать бифуркации, связанные с потерей (приобретением) устойчивости или с изменением размерности его сепаратрис (см. также *Устойчивость движения*).

Лит.: Андронов А. А., Витт А. А., Хаякин Г. Э., Теория колебаний, 3 изд., М., 1981; Баятин Н. Н., Демитович Е. А., Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости, М.,

1978; Ариольд В. И., Дополненные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, М., 1978.

В. С. Абрамowitz, М. И. Рабинович.

РАВНОВЕСНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ молекулы — расположение атомов в молекуле, соответствующее минимуму потенциальной поверхности. Понятие Р. к. имеет смысл только в адиабатическом приближении, при к-ром разделяются электронные и ядерные движения. При строгом рассмотрении говорить о Р. к. молекуле не имеет смысла, т. е. понятие Р. к. является приближенным.

Р. к. относительно устойчива, каждая Р. к. характеризуется определ. внутр. энергией молекулы, переход из одной Р. к. в другую осуществляется при *квантовых переходах*. В случае двухатомной молекулы Р. к. характеризуется равновесным межатомным расстоянием (равновесной длиной связи). В разл. электронных состояниях молекула может иметь разл. Р. к. Так, молекула с линейной Р. к. в осн. электронном состоянии (напр., C_2H_2) в нек-рых возбужденных состояниях имеют величину Р. к.; пирамидальная в осн. состоянии (группа симметрии C_{3v}) молекула NH_3 в возбужденном электронном состоянии $3Z^2E$ имеет плоскую Р. к. (группа симметрии D_{3h}).

В данном состоянии многоатомная молекула может иметь одну или неск. Р. к. При наличии неск. эквивалентных (т. е. получаемых друг из друга при операциях симметрии) Р. к. возможно туннелирование между ними, приводящее к туннельному расщеплению уровней энергии молекулы. Напр., туннелирование между двумя Р. к. молекулы NH_3 приводит к инверсионному расщеплению уровней энергии, величина к-рого составляет ок. 24 ГГц в осн. колебат. состоянии и ок. 35 см⁻¹ в первом возбужденном колебат. состоянии. Неэквивалентные Р. к. наз. конформерами или конформационными молекулами.

Р. к. определяются совокупностью равновесных координат атомных ядер или длин связей и валентных углов, к-рые наз. структурными параметрами молекулы. Для небольших молекул незначит. методы *квантовой химии*, учитывающие электронную корреляцию, позволяют с достаточной точностью ($\sim 0,0005$ и $\sim 0,5^\circ$) определять структурные параметры. Экспериментально структурные параметры можно определить методами *электрографии* и спектроскопии высокого разрешения (в частности, *микроволновой спектроскопии*). Однако на эксперименте определяются эфф. значения структурных параметров, к-рые отличаются от равновесных на (0,005—0,0001) нм. При точности измерений частот вращат. переходов 1—100 кГц такие расхождения на 3—5 порядков выходят за пределы погрешностей измерений. Кроме того, на простых спектральных измерениях можно определить не более трёх вращат. постоянных, тогда как молекула может характеризоваться значительно большим числом структурных параметров. Процедура эксперим. определения всех параметров Р. к. молекулы очень сложна и проделана ещё только для нек-рых 3- и 4-атомных молекул. Структурные параметры, определяемые из эксперимента, несут информацию об адиабатич., неадиабатич., релятивистских и др. поправках, экстрем. значения используют в квантовой механике расчётах.

Лит. см. при ст. *Молекула, Молекулярные спектры*. М. Р. Алев.

РАВНОВЕСНАЯ ОРБИТА в резонансном циклическом ускорителе — орбита, на к-рой период обращения частицы совпадает с периодом ускоряющего напряжения либо кратен ему; в бетатроне — орбита постоянного радиуса, на к-рой выполняется бетатронное условие (см. *Бетатрон*).

РАВНОВЕСНАЯ ПЛАЗМА — плазма, находящаяся в состоянии равновесия термодинамического. На опыте реализуется локальное равновесие, когда состояние плазмы определяется локальным значением давления и темп-ры. Подробнее см. в ст. *Термодинамика плазмы*.

РАВНОВЕСНАЯ ФАЗА — значение фазы Φ_0 ускоряющего ВЧ-напряжения (с амплитудой U_0) в резонансных ускорителях, при к-рой частицы, пришедшие в ускоряющий зазор, приобретают такую энергию $U_0 \cos \Phi_0$, что двигаются в резонансе с ускоряющим полем. Это означает, что в циклических ускорителях частицы на следующем обороте возвращаются к ускоряющему зазору при том же значении фазы, а в линейных ускорителях приходят при той же фазе в следующий ускоряющий промежуток. Одно из двух значений Р. ф. является устойчивым, а другое — неустойчивым (см. *Автофазировка*). В циклич. ускорителях на релятивистские энергии устойчивое и неустойчивое значения фазы в процессе ускорения могут меняться местами (при кризисе энергии). Частицы, приходящие в ускоряющий зазор при устойчивой Р. ф., наз. *равновесными частицами*. Л. Л. Гольдин.

РАВНОВЕСНАЯ ЧАСТИЦА — частица, скорость к-рой постоянно совпадает с фазовой скоростью ускоряющей волны. В резонансном режиме ускорения частицы получают энергию от переменного электрич. поля, сосредоточенного обычно в отд. дискретно расположенных местах орбиты (в циклических ускорителях) или ускоряющего кавала (в линейных ускорителях). Пролетая ускоряющий промежуток, частица приобретает энергию $eU \cos \Phi$, где e — заряд частицы, U — ускоряющее напряжение, Φ — фаза переменного поля в момент пролёта частицы электрич. середины ускоряющего промежутка. Существует только одно значение фазы Φ_0 , к-рое может оставаться всё время постоянным (или медленно меняться но заранее заданному закону). Это значение фазы наз. равновесной фазой. Частица, к-рая каждый ускоряющий промежуток проходит в равновесной фазе, является Р. ч. Орбита, по к-рой в циклич. ускорителе вращается Р. ч., наз. равновесной. Текущее значение энергии Р. ч. в циклич. ускорителе точно соответствует значению магн. поля на равновесной орбите. Б. П. Мурин.

РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ — состояние, в к-рое приходит термодинамич. система при постоянных внеш. условиях. Р. с. характеризуется постоянством во времени термодинамич. параметров и отсутствием в системе потоков вещества и энергии (см. в ст. *Равновесие термодинамическое*).

РАВНОВЕСНЫЙ ПРОЦЕСС (квазистатический процесс) в термодинамике — процесс перехода термодинамич. системы из одного равновесного состояния в другое, столь медленный, что все промежуточные состояния можно рассматривать как равновесные, т. е. характеризующиеся очень медленным (в пределе — бесконечно медленным) изменением термодинамич. параметров состояния. Р. п. — одно из осн. понятий термодинамики равновесных процессов. Всякий Р. п. является обратимым процессом, и наоборот, любой обратимый процесс является равновесным.

РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ системы сил — сила, эквивалентная данной системе сил и равная их геом. сумме: $R = \Sigma F_i$. Система сил, приложенных в одной точке, всегда имеет Р., если $R \neq 0$. Любая др. система сил, приложенных к телу, если $R \neq 0$, имеет Р., когда гл. момент сил этой системы или равен нулю, или перпендикулярен R . В этом случае замена системы сил их Р. допустима лишь тогда, когда тело можно рассматривать как абсолютно твёрдое, и недопустима, напр., при определении внутр. усилий или решения др. задач, требующих учёта деформации тела.

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ точки — движение, при к-ром численная величина скорости v точки постоянна. Закон Р. д. точки даётся равенством $s = s_0 + vt$, где s — измеренное вдоль дуги траектории расстояние точки от выбранного на траектории начала отсчёта, t — время, s_0 — значение s в нач. момент времени $t = 0$. Произведение vt определяет путь, пройденный точкой за время t . При поступат. Р. д. твёрдо-

го тела всё сказанное относится к каждой точке тела; при равномерном вращении вокруг неподвижной оси угл. скорость ω тела постоянна, а закон вращающего действия равенством $\varphi = \varphi_0 + \omega t$, где φ — угол поворота тела, φ_0 — значение φ при $t = 0$.

РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ точки — движение, при к-ром касат. ускорение ω , точки (в случае прямолинейного движения полное ускорение w) постоянно. Закон Р. д. точки и закон изменения её скорости v при этом движении даются равенствами:

$$s = s_0 + v_0 t + \omega t^2/2, \quad v = v_0 + \omega t,$$

где s — измеренное вдоль дуги траектории расстояние точки от выбранного на траектории начала отсчёта, t — время, s_0 — значение s в нач. момент времени $t = 0$, v_0 — нач. значение скорости точки. Когда знаки v и w одинаковы, Р. д. является ускоренным, а когда разные — замедленным.

При поступат. Р. д. твёрдого тела всё сказанное относится к каждой точке тела; при равномерном вращении вокруг неподвижной оси угл. ускорения ϵ тела постоянно, а закон вращающего действия равенствами

$$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \epsilon t^2/2, \quad \omega = \omega_0 + \epsilon t,$$

где φ — угол поворота тела, φ_0 — значение φ в нач. момент времени $t = 0$, ω_0 — нач. угл. скорость тела. Когда знаки ω и ϵ совпадают, вращение является ускоренным, а когда не совпадают — замедленным.

РАВНОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОН — утверждение, согласно к-рому в классич. равновесной статистич. системе ср. кинетич. энергия, приходящаяся на каждую трансляционную, вращательную и колебательную степени свободы, равна $\theta/2$ ($\theta = kT$), ср. потенц. энергия, приходящаяся на каждое гармонич. колебание в системе, — тоже $\theta/2$. Т. о., на каждую колебат. степень свободы в ср. приходится энергия θ — в 2 раза больше, чем на каждую трансляц. и вращат. степень свободы. Р. з. является прямым следствием статистич. вариации теоремы:

$$P_k \frac{\partial H}{\partial p_k} = x_k \frac{\partial H}{\partial x_k} = \theta$$

(чертой сверху обозначено усреднение с помощью классич. канонической распределения Гиббса) и того, что Гамальтона функция системы H представляет квадратич. форму по обобщённым импульсам p_k для любого типа движения в перелытывистости системы и квадратич. форму по обобщённым координатам x_k для каждого происходящего в ней гармонич. колебания.

Р. з. ограничен областью применимости классич. приближения: условие невырожденности газа $\theta \gg \theta_{\text{выр}} = h^3/2m(N/V)^{2/3}$ (см. *Больцмана распределение*), где V — объём системы, содержащий N молекул массой m , обеспечивает применимость Р. з. по отношению к трансляц. движению, условия $\theta \gg \theta_{\text{вращ}} = h^2/2I$ и $\theta \gg \theta_{\text{колеб}} = h\omega_0$ — по отношению к вращению молекул газа и колебат. движениям в них (I — момент инерции, ω_0 — частота собств. колебаний). Численные значения этих характерных темп-р заметно отличаются друг от друга по порядкам величин. Напр., для молекул, входящих в состав воздуха, $\theta_{\text{выр}}/k \approx (10^{-3} \div 10^{-2})$ К, $\theta_{\text{вращ}}/k \approx (1 \div 10)$ К, $\theta_{\text{колеб}}/k \approx 10^3$ К, и поэтому при комнатной темп-ре ($T \approx 300$ К) трансляц. и вращат. движения невырождены и подчиняются Р. з., тогда как колебания как бы выключены («заморожены») и практически не дают своего вклада в термодинамич. характеристики системы. Р. з. эффективно применим в случаях, когда система может быть аппроксимирована идеальной (т. е. учёт взаимодействия частиц даёт малые поправки к равновесным термодинамич. характеристикам газа), а, кроме того, внутр. движения в моле-

кулах (напр., вращающие и колебательные) независимы друг от друга и от поступат. перемещений (трансляций) молекул.

Для расчёта внутр. энергии ϵ и теплоёмкости при пост. объёме $C_V = d\epsilon/dT$ газа, состоящего из N -атомных молекул (общее число молекул — N), следует подчитать число независимых степеней свободы, приходящихся на одну молекулу: 3 трансляционные, 3 вращательные, $3n-6$ колебательных (в линейных молекулах 2 вращательных и $3n-5$ колебательных), и воспользоваться Р. з. Тогда $\epsilon = N \cdot 3(n-1)\theta/2$ для газа из линейных молекул $\epsilon = N \cdot 3(n-4)\theta/2$. Для проты твёрдых тел, рассматриваемых в гармонич. приближении (см. *Динамика кристаллической решётки*), из Р. з. при темп-рах выше Дебая температуры следует Дюлонга и Липи закон $\epsilon = N \cdot 3\theta$ для молярной теплоёмкости кристалла, $C_{\text{мол}} = 3R$ (R — универсальная газовая постоянная). Для равновесного излучения Р. з. приводит к Рэлея—Джисса закону излучения, справедливому в области низких частот $\omega \ll \theta/h$.

Лит.: К л а с с и к о в И. А., Термодинамика и статистическая физика, М., 1991. И. А. К л а с с и к о в.

РАД (rad, сократ. от англ. radiation absorbed dose — поглощённая доза излучения) — внесистемная единица поглощённой дозы излучения; соответствует энергии излучения 100 эрг, поглощённой веществом массой 1 г. 1 рад = 100 эрг/г = $0,01 \text{ эрг/г} = 2,388 \cdot 10^{-6}$ кал/г.

РАДИАЛЬНО-ФАЗОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ в ускорителях x — совокупность взаимосвязанных колебаний фаз, радиусов орбит и энергий заряд. частиц вблизи их равновесных значений. Для практич. реализации режима резонансного ускорения в циклическом ускорителе нужно, чтобы достаточно большое кол-во неравновесных частиц не выходило из этого режима, несмотря на то, что для них возникают отклонения от точного синхронизма. Резонансный режим ускорения осуществляется благодаря эффекту автофазировки, заключающемуся в том, что переносное ускоряющее поле с периодом T обладает свойством заставлять частицу двигаться по орбите с периодом, в ср. равным или кратным T . Предположим для определенности, что с ростом энергии угл. частота обращения частицы в данном магн. поле убывает, а равновесная фаза частицы расположена на спаде гребня синусоиды напряжения. Если по к.-л. обстоятельствам частица по фазе опережает равновесную частицу, то она будет получать меньше энергии. Период её обращения T уменьшится, частица будет отставать по фазе, опережение будет уменьшаться. Авантогично, если частица отстаёт по фазе, то она будет получать больше энергии, период обращения возрастет и отставание будет ликвидировано. Т. о., фаза частицы колеблется около равновесной фазы, а радиус её орбиты по превышает радиус орбиты равновесной частицы, то, наоборот, становится меньше; такое связанное колебание фазы и радиуса и наз. Р.-ф. к.

Р.-ф. к. могут быть свободными и вынужденными. Свободные Р.-ф. к. обусловлены нач. разбросом фаз и энергий частиц и описываются однородным дифференц. уравнем. Вынужденные Р.-ф. к. обусловлены возмущениями величин ведущего магн. поля, частоты и амплитуды ускоряющего напряжения и описываются неоднородным дифференц. уравнем.

Лит. см. при ст. *Циклический ускоритель*. Б. П. М е р д и н.
РАДИАН (от лат. radius — луч, радиус) (рад, рад.) — единица плоского угла; 1 рад равен углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между к-рыми равна радиусу. 1 рад = $57^{\circ}47'44,8'' \approx 3,44 \cdot 10^8$ угл. минут $\approx 2,06 \cdot 10^5$ угл. секунд.

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ — наука о действиях ионизирующей излучений на биол. объекты. Поражающее действие ионизирующих излучений обусловлено ионизацией макромолекул нуклеиновых кислот, белков и др. Различают два пути воздействия: прямой, при к-ром энергия излучения поглощается непосредственно в самих макромолекулах, и косвенный, при к-ром

энергия поглощается водой и низкомолекулярными соединениями, содержащимися в объекте, а поврежденные макромолекулы наводятся свободными радикалами — продуктами радиолиза. При поглощенной дозе всего лишь в 0,01 Гр (1 рад) в каждой клетке осуществляются сотни тысяч актов ионизаций в клеточных структурах [ядре, цитоплазме, мембранах (см. *Биофизика*)], что приводит к множеству нарушений жизнедеятельности клетки. Однако большинство нарушений проходящих и не вызывают гибели клетки.

В животном организме клетки одних тканей (кровотворные, половых органов, слизистой кишечника) активно делятся, воспроизводят себе подобные; клетки других тканей (шочек, печени, сердца, мышц, нейроны и др.) делятся редко или вообще не делятся. Соответственно различают два вида гибели клеток — репродуктивную и интерфазную. Репродуктивная гибель состоит в нарушении способности делящихся клеток к неограниченному воспроизводству: после 1–2 делений дефектные потомки клеток отмирают. При интерфазной гибели вскоре после облучения гибнут сами облученные клетки. Для всех делящихся и большинства неделящихся клеток интерфазная гибель наступает лишь при дозах в сотни Гр. Исключение составляют лимфоциты и половые клетки на некоторых стадиях их развития; они гибнут интерфазно уже при дозах в десятках Гр.

Причины и закономерности репродуктивной и интерфазной гибели различны. Наиб. изучена репродуктивная гибель. Она наступает в результате повреждения молекул ДНК, завершающегося разрывом одной или обеих ее нитей, что препятствует дальнейшему воспроизводству нормальных клеток. Зависимость доли клеток, сохраняющих репродуктивную способность после облучения в дозе D , имеет вид

$$N(D)/N(0) = \exp(-SD) = \exp(-D/D_0).$$

Здесь $N(0)$ и $N(D)$ — число клеток до и после облучения; величина $S = 1/D_0$ характеризует радиочувствительность клеток, D_0 — доза, снижающая число выживших клеток в e раз. Для большинства делящихся клеток $D_0 = (1,2 \div 2,0)$ Гр. Часто экспоненциальному участку дозовой кривой предшествует участок кривой с меньшим наклоном (рис. 1).

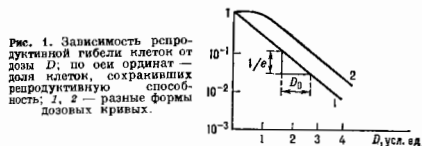


Рис. 1. Зависимость репродуктивной гибели клеток от дозы D ; по оси ординат — доля клеток, сохраняющих репродуктивную способность; 1, 2 — разные формы дозовых кривых.

Радиочувствительность делящихся клеток зависит от многих факторов и может быть искусственно увеличена (сенсибилизация) или уменьшена (защита); соответственно D_0 уменьшается или увеличивается. Наиб. эффективным сестев. спонсбилизатором является кислород: в его отсутствие поряжение различных биол. объектов (макромолекул, клеток, организмов в целом), как правило, ослабляется (кислородный эффект). При этом D_0 для клеток увеличивается в 3 раза. С ростом линейной плотности ионизации радиочувствительность клеток и тканей возрастает.

Повреждение ДНК, обуславливающее репродуктивную гибель клеток, не является для нее фатальным благодаря существованию мощных систем восстановления (репарации). Часть возникающих в результате ионизации первичных повреждений репарируется хим. восстановителями, присутствующими в клетке. Осн. восстановителем является аминокислота глутатин. Она концентрируется в внутриклеточном кислороде,

фиксирующим первичные повреждения, и препятствует их восстановлению. Повреждения, сохраняющиеся после этого физ.-хим. этапа репарации, эффективно устраняются ферментными системами, специфически репарирующими разл. виды генетич. повреждений. Ковечный поражающий эффект облучения обусловлен неотренированной частью первичных повреждений ДНК. Доля их в обычных условиях невелика (доли %), что и обуславливает отосит. устойчивость живых клеток к действию ионизирующих излучений. С этим же связана возможность увеличить радиочувствительность, искусственно подавляя способность делящихся клеток к репарации, либо связать их радиочувствительность, создавая условия для лучшей репарации потенц. повреждений ДНК.

Механизм интерфазной гибели клеток изучен слабее, неясна и причина резкого отличия в радиочувствительности лимфоцитов от др. видов клеток. В отличие от репродуктивной гибели, изменения, ведущие к интерфазной гибели, наблюдаются во всех клетках и с дозой облучения меняется не доля погибших клеток, а ср. время гибели всей популяции (рис. 2). Причина различий, по-видимому, в том, что интерфазная гибель обус-

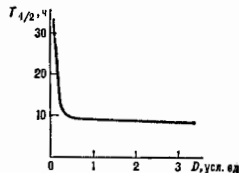


Рис. 2. Зависимость интерфазной гибели лимфоцитов от дозы; по оси ординат — время гибели половины облученных клеток ($T_{1/2}$).

ловлена повреждением не уникальной структуры клетки (ДНК), а мембран и др. множественных ее структур.

Радиационная гибель целостного организма млекопитающих обусловлена опустошением популяций делящихся клеток и тканей т.к. критических органов, необходимых для жизнедеятельности. Такими органами являются кроветворные и пищеварительные. В кроветворных органах (костный мозг, селезенка) и тонком кишечнике есть активно делящиеся клетки, являющиеся родоначальниками (стволовыми) для всех функционирующих клеток крови и клеток тонкого кишечника, ответственных за всасывание питательных веществ. Репродуктивная гибель стволовых клеток, связывающая их численность ниже совместимого с жизнью критич. уровня, приводит к гибели организма.

На рис. 3 приведена дозовая кривая выживаемости млекопитающих при облучении всего организма. Доза летальности 50% особей в популяции (LD_{50})



Рис. 3. Дозовая кривая гибели млекопитающих.

различна для млекопитающих разных видов, но форма дозовой кривой и причины гибели одинаковы. При дозах порядка LD_{50} критической для организма является система кроветворения, при больших дозах — слизистая оболочка тонкого кишечника. В первом случае часть животных гибнет через 10–14 дней, во втором — через 4–7 дней после облучения. При $D > 1$ Гр вплоть до абс. летальной дозы у выживших особей наблюдается и леченая болезнь разной тяжести.

Существует ряд мер профилактики, защиты организма от облучения. Наиб. эффективны два класса хим. защитных веществ (радиопротекторов) при введении их за 10—15 мин до облучения. Это соединения, содержащие серу, — тиолы и гидродиталды и дитамиды. Первые, подобно внутриклеточному глутатиону, способствуют физ.-хим. репарации первичных повреждений, конкурируя с кислородом и, по-видимому, способствуя ферментативной репарации. Вторые сужают сосуды и тем самым также ослабляют поражающее действие кислорода в облученных клетках критич. органов.

В нек-рых случаях необходимо увеличить радиочувствительность клеток, напр. при радиотерапии опухолей. Сенсибилизаторы могут служить т. н. электронакцепторные соединения, роль к-рых аналогична действию кислорода, но они лучше проникают в глубь опухоли.

Понимая повреждений, проявляющихся вскоре после облучения в больших дозах, монизирующее излучение вызывает отдаленные последствия (в осн. канцерогенез и генетич. нарушения), к-рые могут возникнуть при любых дозах и характере облучения (равном, хронич., локальном). Вероятность возникновения отдаленных последствий возрастает с дозой, но экспериментально она определена лишь при достаточной больших дозах. Достоверному определению её при малых дозах препятствуют отсутствие достаточной статистич. материала и адекватных контрольных групп животных, а главное, огромный фон аналогичных заболеваний у человека, вызванных иными канцерогенными и мутагенными факторами окружающей среды. Поэтому при нормировании допустимых доз облучения (см. *Нормы радиационной безопасности*) вероятность отдаленных последствий рассчитывают, используя линейную экстраполяцию эффекта больших доз в область малых и при допущениях о тождественности возникающих повреждений и возможности переноса данных с животных на человека.

Среди патологич. изменений, вызываемых облучением в живых организмах, встречаются такие, к-рые являются полезными для человека. Напр., под действием опред. доз облучения в нек-рых случаях на растениях наблюдается т. н. стимуляционный эффект (более раннее созревание, увеличение зеленой массы, накопление полезных продуктов обмена веществ и т. п.). Практич. значение имеет облучение с целью выведения полезных мутантов растений, бактерий (напр., вырабатывающих пенициллин) и др. Поражающее действие используется в радиотерапии злокачеств. опухолей, а также для стерилизации лекарств, препаратов и перевязочных материалов, дезинсекции зерна, предотвращения прорастания картофеля и др. В научных исследованиях биол. действие радиации применяется для определения размеров макромолекул, вирусов и бактерий, изучения топографии радиочувств. структур в клетке, исследования процессов миграции энергии в белках и нуклеиновых кислотах, выяснения роли отд. клеточных образований в эмбриогенезе и др.

Развитие Р. б. привело к появлению самостоятельных её направлений: радиационной и генетич., радиационной микробиологии, радиоэкологии, космич. Р. б. и др.

Лит.: Ли Д. Э., Действие радиации на живые клетки, пер. с англ., М., 1963; Эйдуз Д. Х., Физико-химические основы радиационных процессов и защиты от излучений, 2 изд., М., 1979; Яромоненко С. П., Радиобиология человека и животных, 3 изд., М., 1986; Когг Д. Ж., Биологические эффекты радиации, пер. с англ., М., 1986. Л. Х. Эйдуз.

РАДИАЦИОННАЯ ЕДИНИЦА ДЛИНЫ (каскадная, линейная, t -единица) — расстояние x_0 , на к-ром интенсивность гамма-излучения и потока электронов высокой энергии ослабляется в e раз. Первоначально введена для описания взаимодействия космических лучей с веществом:

$$x_0^{-1} = 4\alpha r_0^2 \sum_i n_i Z_i (Z_i + 1) \ln \left(183 Z_i^{-1/3} \right) \text{ [см}^{-1}\text{]}.$$

Здесь n_i — число атомов сорта i в 1 см^3 , Z_i — заряд ядра, r_0 — радиус электрона, $\alpha = 1/137$ (x_0 выражено в см). С помощью Р. е. д. мн. сложные процессы — тормозное излучение, образование пар, кулоновское многократное рассеяние — записываются в простой форме. Напр., тормозное излучение электронов в поле ядер не зависит от энергии e электрона:

$$\frac{1}{e} \left(\frac{de}{dx} \right) = \frac{1}{x_0},$$

т. е. $e = e_0 \exp(-x/x_0)$ и при $x = x_0$ энергии электрона e убывает в e раз (см. *Радиационные потери*). Это означает, что проникающая способность электронов, а следовательно, интенсивность тормозного излучения, не возрастает с увеличением их энергии.

Вероятность образования пар (e^+e^- -квантами при $e > 1.02 \text{ МэВ}$) (m — масса электрона) также не зависит от энергии γ -кванта и на длине x_0 равна γ_0 . При $e < 2mc^2$ образование пар прекращается и идет процесс комптоновского рассеяния (см. в ст. *Комптон эффект, Гамма-излучение*).

Многократное кулоновское рассеяние приводит к искривлению траектории заряж. частиц тем больше, чем меньше x_0 (см. *Пузырьковая камера, Ядерная фотографическая эмульсия*).

В справочниках обычно приводятся Р. е. д. в г/см^2 , т. е. в виде, не зависящем от состояния вещества. Определение Р. е. д. в см для опред. агрегатного состояния вещества (при разл. термодинамич. условиях) производится делением этой величины на плотность. В табл. даны примеры определения x_0 для разных состояний нек-рых веществ, используемых в экспериментах.

	x_0 , г/см ²	ρ , г/см ³	x_0 , см	Агрегатное состояние
H ₂	62,8	0,06	1047	жидкое
Cu	44,6	8,43	104	жидкое
Pb	6,37	11,34	0,57	твердое
Fe	13,84	7,8	1,78	твердое
Воздух	37,...	$1,29 \times 10^{-3}$	28680	газ при 1 атм

Лит.: Россин Б., Грейзен К., Взаимодействие космических лучей с веществом, пер. с англ., М., 1948; Основные формулы физики, под ред. Д. Мензель, пер. с англ., М., 1957; Мурзин В. С., Введение в физику космических лучей, 3 изд., М., 1988.

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА — 1) методы ослабления воздействия ионизирующих излучений до допустимого уровня; 2) Комплекс сооружений, снижающий интенсивность излучения источника. Осн. задача Р. з. — обеспечение безопасности как персонала, работающего в полях ионизирующих излучений, так и людей,意外но подвергавшихся облучению, за счёт снижения индивидуальных эквивалентных доз ниже предельно допустимых уровней (см. *Нормы радиационной безопасности*). Проблема Р. з. возникла с открытием рентг. излучения и радиоактивности и до кон. 30-х гг. 20 в. развивалась в связи с задачами обеспечения радиац. безопасности персонала медицинских учреждений, применяющего герметичные точечные источники излучений в терапевтич. целях. Вносистемности в ходе работ по созданию ядерного оружия были решены задачи Р. з. работников урановых рудников, газодиффузионных обогатит. заводов (см. *Изотопное разделение*) и др. предпринят по изготовлению ядерного топлива, а также конструированию многослойной защиты от проникающих излучений мощных ядерных реакторов (γ -излучение, нейтроны). В дальнейшем сформировалась новая ветвь Р. з. — защита биосферы от воздействия ядерной энергетики, в т. ч. при захоронении отходов

высокой удельной активности (напр., отработавших твдел).

Радиацию Р. з. при внеш. облучении (обусловлена герметичными источниками вне организма человека) и при внутр. облучении (обусловлена радионуклидами, попадающими в тело человека с загрязнённым воздухом, водой, пищей или через кожу).

Для описания переноса проникающего излучения в вещество используют у-рние Больцмана. Его решения при разл. граничных условиях (бесконечная и полубесконечная среда, сферич. и плоский барьер в воздухе и др.), упрощённые до инженерных ф-л., — осн. метод расчёта Р. з. от проникающих излучений. При описании взаимодействия излучения с веществом важны интенсивность потока излучения (*флюенс*), плотность потока, поглощённая энергия (см. *Доза излучения*) и др.

Радиационная защита от внешнего воздействия α - и β -частиц обеспечивается малыми толщинами поглощения: для полного поглощения α -частиц с макс. пробегом $\sim 8-9$ см воздуха достаточно лист бумаги, для β -частиц с макс. пробегом до 1 м воздуха достаточно слой Al толщиной 5-7 мм. В случае γ -излучения каждый акт рассеяния сопровождается выведением фотона на периф. Для расчёта Р. з. от узкого пучка γ -излучения используют *Ламберта закон*:

$$I(t) = I_0 \exp(-Lt). \quad (1)$$

Здесь I_0 — нач. интенсивность излучения, t — толщина защитной среды, L — линейный коэф. ослабления γ -излучения в этой среде, обусловленный фотоэффектом, комптоновским рассеянием и образованием пар. При энергии фотона меньше 200 кэВ доминирует фотоэффект. Его вероятность по мере роста энергии фотона ϵ уменьшается, и осн. вклад в L до $\epsilon \approx (1-2)$ МэВ даёт комптоновское рассеяние. При $\epsilon \approx (3,3-5,0)$ МэВ для тяжёлых и (15-50) МэВ для лёгких элементов начинается рост L , обусловленный образованием пар. В Р. з. часто применяют массовый коэф. поглощения γ -излучения (в см²/г):

$$\mu = \frac{N}{A} \sigma, \quad (2)$$

где N — число Авогадро, A — атомный вес, σ — сечение процесса. В области, где доминирует комптоновское рассеяние, $\mu \approx \text{const}$, т. к. $Z/A \approx 1/2$ для всех элементов, кроме водорода (Z — ат. номер).



Рис. 1. Зависимость поглощённой дозы D от расстояния r до точечного источника нейтронного излучения ($\epsilon_0 = 0,256$ МэВ), среда — H_2O .

Для расчёта Р. з. от широкого пучка γ -излучения используют понятие длины релаксации R — толщины вещества, ослабляющей интенсивность излучения в e раз. Значения R , определяемые экспериментально, зависят от ϵ и Z вещества. Напр., для γ -квантов с $\epsilon \approx 1$ МэВ длина релаксации R составляет (в см): для воды 14,2, для Al 6,1, для Fe 2,1, для Pb 1,3.

Геометрия широкого пучка относится к наиб. важным случаям, в частности, Р. з. ядерных реакторов. В этом случае происходит накопление рассеянных фотонов (рис. 1), для учёта к-рого вводится фактор накопления V (энергетич., дозовый и др.). Его определяют экспериментально либо рассчитывают методами теории переноса излучения, напр. *Монте-Карло методом*, *Далласа преобразованиями*. При малой энергии фотонов ϵ и больших толщинах защитного слоя, особенно при использовании дешёвых лёгких материалов (напр., H_2O , бетон), V может достигать больших значений (рис. 2).

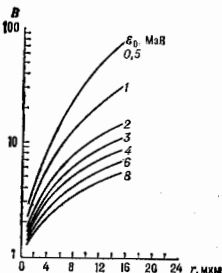


Рис. 2. Зависимость фактора накопления V от расстояния r до источника при разных энергиях фотона.

Особенно важна Р. з. в случае проникающего нейтронного излучения. Проникновение нейтронов через защитный слой анализируют в осн. методом моментов, методом Монте-Карло и численного интегрирования у-рия Больцмана. Ослабление потока быстрых нейтронов в защитном слое происходит из-за упругого (особенно в водородосодержащих веществах: H_2O , парафин, полиэтилен, гидриды металлов, бетоны) и неупругого рассеяния нейтронов. На достаточном больших расстояниях от плоского источника ослабление пучка с расстоянием происходит экспоненциально. Р. з. ядерного реактора отличается тем, что поглощение в защитном слое одного вида частиц, напр. *тепловые нейтроны*, как правило, сопровождается возникновением γ -излучения [ядерная реакция (п. γ)]. Так, при поглощении теплового нейтрона ядром водорода образуется фотон с энергией 2,2 МэВ, а в случае более эфф. поглощения (напр., Cd) на один захваченный нейтрон приходится более 40 фотонов. Оптимальная Р. з. реактора содержит водородосодержащие вещества или графит, замедляющие быстрые нейтроны до тепловых энергий (см. *Замедление нейтронов*), и идра, захватывающие тепловые нейтроны (В, Cd, Gd). На АЭС обычно используют бетон с добавками металлов, скрана и дробн, эффektivно ослабляющий как нейтронное, так и γ -излучение.

Радиационная защита от внутреннего облучения. При подземной добыче урановых руд для снижения концентрации Rn и продуктов его распада применяют изоляцию выработанных штреков, вытяжную вентиляцию с интенсивным отсосом воздуха изблин мест выделения радиоакт. газа и др. При открытой добыче урановых руд наиб. эффektivны очистка воздуха от радиоакт. аэрозолей и подача его в кабину оператора бульдозера, экскаватора или автомашин.

При работе в атмосфере радиоакт. газов и аэрозолей при их концентрации не более 200 допустимых концентраций (ДК) используют респираторы «Лестонек» (на основе фильтрующей ткани с зариз. волоками), маски с фильтрующими насадками (сорбенты для улавливания I); при содержании радионуклидов от 200 до 1000 ДК применяют пневмомаски и пневмокостюмы с поддувом чистого воздуха в зону дыхания; при

концентрации более 2000 ДК используют изолирующие костюмы и скафандры с автономными системами воздухообеспечения.

Радиоактивные инертные газы не концентрируются в теле человека. Они опасны только как внешние β - и γ -излучатели, их концентрации достигают опасных пределов лишь при аварии с разрушением защитных барьеров и образованием облака короткоживущих нуклидов. При переносе такого облака за пределы т. и. с. и т. а. р. - защитной зоны может возникнуть облучение населения сверх допустимого предела. Р. в. населения сводится к укрытию в подвальных помещениях жилых домов (коэф. ослабления облучения для деревянного дома составляет ~ 7 , для каменного $\sim 40-100$).

Для защиты от короткоживущих Кг и Хе (см. *Деление ядер*) используют гадолиды. Возникающие при их распаде дочерние радиоакт. аэрозоли улавливают фильтрацией воздуха. На радиохим. заводах применяют излучение Кг и Хе на воздухе методом низкотемпературной дистилляции и адсорбции газов.

Некоторые органы человека избирательно концентрируют определ. элементы (напр., цитовидная железа — I, костная ткань — Sr). В результате этого в цитовидной железе может накапливаться радиоуклуд ^{131}I , в костях — ^{90}Sr . Для защиты этих органов применяют iodную профилактику, в пищу вводят Са (для снижения количества Sr в костях), комплексобразователи, стимулирующие выделение радионуклидов (напр., выведение Pu), адсорбенты, ограничивающие поступление радиоакт. веществ в кровь при их заглатывании. Разработаны хим. препараты, снижающие радиобиол. последствия больших доз облучения при введении их до облучения.

По данным многолетних наблюдений персонала крупных ядерных объектов, измеримо содержание радионуклидов обнаруживается у 3—5% контролируемых лиц. При этом уровни активности не превышают сотых долей допустимого содержания в теле человека.

Наибольшие источники радиационной опасности — отвалы урановых рудников, ядерно-энергетич. установки (ЯЭУ) атомных электростанций, хранилища отходов. Не требуют Р. з. долгоживущие радиоуклуды — ^{85}Kr (период полураспада $T_{1/2} = 10,5$ года), ^3H (12,3 года), ^{14}C (5700 лет). В конечном счёте ^3H и ^{14}C в H_2O и CO_2 поступают в Мировой океан, ^{85}Kr накапливается в атмосфере. До кон. 20 в. годовая доза облучения населения Земли за счёт этих глобальных радионуклидов не превышает 1 мбэр, т. е. 1% дозы, обусловленной естеств. радиац. фоном.

Р. з. населения от внутр. облучения за счёт радиоакт. отходов урановых рудников осуществляется с помощью покрытия отвалов слоем глинистых материалов, посева на них растительности, помещения отходов в выработанные шпелки и штольни. Р. з. населения, проживающего вблизи крупных ЯЭУ, обеспечивается с помощью многобарьерной системы. Каждый из барьеров — матрица ядерного топлива, герметичная оболочка твэла, герметичный контур первичного теплоносителя, локализуяющие боксы со спец. вентиляцией и канализацией для пелет 1-го контура, установок поддержания активности (см. *Ядерный реактор*) — снижает вероятность выхода накопленных радионуклидов в окружающую среду. На большинстве АЭС радиационно опасное оборудование окружает герметичной защитной оболочкой, к-рая способна противостоять повыш. давлению паровоздушной смеси, возникающей в случае разрушения 1-го контура и плавления активной зоны. При создании хранилищ отходов высокой уд. активности также используется многобарьерная система: перевод жидких отходов в твёрдую фазу (остекловывание, получение керамики), коррозионно-стойкие контейнеры, геохим. барьеры вокруг контейнеров, захоронение в геологически стабильных формах, изолирование от подпочвенных вод. В случае разрушения хра-

нилища доза облучения населения не превышает сотых долей процента соответствующего предела доз (см. *Нормы радиационной безопасности*).

Эффективность Р. з. населения (рис. 3) высока для ядерных установок (дополнит. годовая доза облучения не более 1 мбэр), в то же время Р. з. при медицинском использовании источника ионизирующего излучения недостаточна (годовая доза приближается к дозе, обусловленной естеств. радиац. фоном).



Рис. 3. Относительный вклад различных источников радиации в дозу облучения населения Земли.

Лит.: Гольдштейн Г., Основы защиты реакторов, пер. с англ., М., 1961; Машкович В. П., Защита от ионизирующих излучений, 3 изд., М., 1962; Защита от ионизирующего излучения, под ред. Н. Г. Гусева, 2 изд., т. 1—2, М., 1980—83, Ю. В. Сильченко.

РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (твёрдых) — способность материалов сохранять свойства (механич., электр., оптические и др.) при воздействии радиации. Изменение свойств обусловлено смещениями атомов в кристаллич. решётке (см. *Радиационные дефекты*), ядерными реакциями, разрывами хим. связей и др. Изменения могут быть обратимыми и необратимыми. Последние обусловлены преим. хим. превращениями молекул.

Наиб. воздействие оказывают нейтронное и γ -излучение. На практике изменение свойств материала составляет с величиной, характеризующей действующее излучение, напр. с *флюенсом* нейтронов или поглощённой дозой γ -излучения.

Мн. свойства *кристаллов* чувствительны к повреждениям кристаллич. решётки. Одниосные дефекты обычно упрочняют металл, но снижают его *пластичность*. Электросопротивление металлов или сплавов возрастает за счёт образования дефектов, хотя в сплавах возможно уменьшение электросопротивления, если радиац. воздействие приводит к упорядочению структуры. В полупроводниках под действием облучения концентрация точечных *дефектов* увеличивается, что приводит к изменению электр. и оптич. свойств.

Изменение свойств органич. веществ связано гл. обр. с процессами возбуждения и ионизации молекул. При этом образуются неравновесные электроны, ионы, ионные радикалы, молекулы в возбуждённом состоянии. Взаимодействие излучения с органич. веществами сопровождается газовыделением. радиац. стойкость органич. веществ зависит от кол-ва растворённого в них O_2 в скорости его поступления из окружающей среды. В присутствии O_2 происходит радиац.-хим. окисление веществ. В результате намевляется хим. и термич. стойкость вещества, может возрасти его хим. агрессивность по отношению к конструкц. материалам. «Сшивание» и деструкция *полимеров* — необратимые процессы, к-рые приводят к наиб. значит. повреждениям структуры.

Осн. показатели, характеризующие необратимые изменения для механич. свойств полимерных материалов, — предел прочности, модуль упругости, предел деформируемости; для электр. свойств — изменения

диэлектрич. проницаемости, тангенса угла диэлектрич. потерь, электрич. прочности, проводимости.

Обратимые изменения обусловлены установлением стационарного равновесия между генерацией нестабильных продуктов радиолиза и их гибелью, поэтому они зависят от мощности дозы. Сопровождение органич. моляци. материалов падает с увеличением мощности дозы на неск. порядков. При больших дозах снижение остаточного электрич. сопротивления металлов носит необратимый характер. У ми. полимерных материалов, облучённых до доз 10^8 Гр, исходная электрич. проводимость изменяется в неск. раз (при дозе $\sim 10^4$ Гр изменения, как правило, незначительны).

В органич. материалах может возникать посперацион. старение, к-рое обусловлено в осн. хим. реакциями свободных радикалов, образовавшихся при облучении полимеров с кислородом воздуха. Радиацион. стойкость полимерных диэлектриков определяется, как правило, их механич. (а не электрич.) свойствами, т. к. большинство полимеров становятся хрупкими и теряют способность нести механич. нагрузки после доз, к-рые ещё не вызывают существ. изменений электрич. свойств.

Радиацион. стойкость неорганич. веществ зависит от их кристаллич. структуры и типа хим. связи. Наиб. стойкими являются ионные кристаллы. Плотные структуры с высокой симметрией наиб. устойчивы к воздействию ионизаций. Для стёкол характерны изменение прозрачности и появление окраски, возникновение кристаллизации (см. *Стеклообразное состояние*). Силикаты начи-

нают изменять свойства после облучения флюэоном нейтронов $\sim 10^8$ см⁻². В результате облучения происходит анизотропное расширение кристалла, аморфизация его структуры, уменьшение плотности, упругости, теплопроводности и др. Оксиды меняют свойства аналогично силикатам, но в меньшей степени. Сущест. изменения в свойствах бетонов отсутствуют при облучениях нейтронными потоками с флюэоном до $3 \cdot 10^{10}$ см⁻².

В табл. 1 и 2 приведены мин. уровни облучения, вызывающие заметные (20–30%) изменения свойств нек-рых материалов.

Лит.: Вавилов В. С., Ухин Н. А., Радиационные эффекты в полупроводниках и полупроводниковых приборах, М., 1969; Радиационная стойкость материалов. Справочник, под ред. В. Б. Лубовского, М., 1973; Радиационная стойкость материалов радиотехнических конструкций. Справочник, под ред. Н. А. Сидорова, В. К. Князева, М., 1976; Радиационное электропроводление, М., 1978; Действие проникающей радиации на изделия электронной техники, под ред. Е. А. Падыхина, М., 1980; Радиационная стойкость органических материалов. Справочник, под ред. В. К. Миллинчука, В. И. Тупинова, М., 1986; Вавилов В. С., Кекселева Е. П., Смирнов Л. С., Действие излучений на полимеры, М., 1988.

РАДИАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА — физ. величина T_r , определяющая суммарную (по всему спектру) энергетич. яркость B_0 теплового излучения тела при темп-ре T ; равна темп-ре T_d абсолютно чёрного тела, при к-рой его суммарная энергетич. яркость $B_0 = B_d$.

Стефана — Больцмана закон излучения для полной испускат. способности (связанной с энергетич. яркостью) $\epsilon = \sigma T^4$ (σ — постоянная Стефана — Больцмана) позволяет записать $\sigma T_r^4 = \epsilon T \sigma T^4$, где ϵT — коэф. черноты тела при темп-ре T . Р. т. $T_r = T_d$ измеряется радиан. пирометром, и, если известен коэф. ϵT , можно определить T_r . Такой метод используют для измерения высоких темп-р.

РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ — раздел химии, включающий исследования хим. превращений в веществах, обусловленных действием разл. ионизирующих излучений. В задачи Р. х. входит выявление механизмов радиац.-хим. превращений, создание материалов с высокой радиац. стойкостью, необходимых для получения и переработки *атомного горючего*, а также препаратов для защиты живых организмов от воздействия излучений. Р. х. взаимодействует при этом с *радиационной биологией* и медициной. На методах Р. х. основаны радиац. синтез полимеров, деструкция радиоакт. отходов под действием излучения и др.

РАДИАЦИОННОЕ ТРЕНИЕ — то же, что *реакция замедления*.

РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ — *дефекты* кристаллич. структуры, образующиеся при их облучении потоками частиц или квантов эл.-магн. излучения. Энергич. передача твёрдому телу (мишени) может привести к разрыву межатомных связей и смещению атомов с образованием перичного Р. д. типа *Френкеля пары* (вакансия и межатомный атом).

Эл.-магн. излучение (оптич. фотоны, γ -кванты, рентг. кванты) непосредственно возбуждает электронную систему кристалла, и лишь на след. этапе включаются разл. механизмы смещения атомов. Это — взаимодействие атомов с электронами, энергия к-рых достаточна для смещения атома; смещение ионизован. алектронным ударом атома из-за электр. отталкивания от одноимённого заряженного, близко расположенного прямиесного иона; смещение соседних, одновременно ионизован. атомов, и др. Возможно также смещение атомов из-за отдачи при *фотоядерных реакциях* (γ, n).

При нейтронном облучении налетающая частица смещает атом в том случае, если передаёт ему в упругих соударениях (без возбуждения электронной системы) энергию E , превышающую нек-рую пороговую E_d . Типичные значения E_d составляют 10–80 эВ. Вылет из ядра продуктов ядерных реакций, инцидируемых нейтронами, также может вызвать смещение атомов

Табл. 1.

Органические материалы	Доза γ -излучения, Гр
Термоактивные смолы	
Фенольная смола с наполнителем из стекловолокна	$3 \cdot 10^7 - 10^8$
Фенольная смола с асбестовым наполнителем	$10^8 - 3 \cdot 10^7$
Полиэфир с наполнителем из стекловолокна	$10^7 - 3 \cdot 10^7$
Эпоксидная смола	$10^8 - 2 \cdot 10^7$
Маялар	$2 \cdot 10^8 - 2 \cdot 10^8$
Полиэфирная смола без наполнителя	$3 \cdot 10^8 - 10^8$
Силикон без наполнителя	$10^8 - 5 \cdot 10^8$
Термоластичные смолы	
Полиэтирол	$5 \cdot 10^8 - 5 \cdot 10^7$
Поливинилхлорид	$10^8 - 10^7$
Полиэтилен	$10^8 - 10^8$
Полипропилен	$5 \cdot 10^8 - 10^8$
Акрилнитрилоловое	$10^8 - 3 \cdot 10^8$
Нитроцеллюлоза	$5 \cdot 10^8 - 2 \cdot 10^8$
Полиметилметакрилат	$5 \cdot 10^8 - 10^8$
Полуретан	$10^8 - 10^8$
Тейлон	$2 \cdot 10^8 - 5 \cdot 10^8$
Тейлон 100X	$5 \cdot 10^8 - 10^8$
Эластомеры	
Натуральный каучук	$5 \cdot 10^8 - 5 \cdot 10^8$
Полуретановые каучуки	$10^8 - 3 \cdot 10^8$
Акриловые эластомеры	$10^8 - 7 \cdot 10^8$
Крепильноорганические эластомеры	$10^8 - 10^8$
Бутиловые эластомеры	$10^8 - 3 \cdot 10^8$

Табл. 2.

Неорганические материалы	Доза γ -излучения, Гр	Флюэенс нейтронов, см ⁻²
Стекло	$5 \cdot 10^7$	$5 \cdot 10^{17}$
Керамика	—	$10^{18} - 3 \cdot 10^{18}$
Железо	—	$2 \cdot 10^{17} - 3 \cdot 10^{17}$
Сталь конструкционная	—	10^{18}
Бетон	—	$10^{18} - 5 \cdot 10^{18}$
В1 (германиевые транзисторы)	$10^8 - 10^8$	$3 \cdot 10^{11} - 10^{11}$
Ge (германиевые транзисторы)	$10^8 - 10^8$	$4 \cdot 10^{11} - 10^{11}$

в результате отдачи. Облучение заряд. частицами (электронами, позитронами, протонами, ионами) сопровождается как упругой (передача энергии электрона), так и упругой передачей энергии атомам мишени. Соответственно образование Р. д. при таких воздействиях протекает по механизмам, характерным для облучения как нейтронами, так и эл.-магн. квантами.

Образование Р. д. при передаче энергии электронам возможно гл. обр. в диэлектриках и полупроводниках. В металлах энергия, эстраченная радиацией на возбуждение атомарных структур, преим. превращается в тепло, не создавая дефектов структуры.

Если энергия, к-рой обладает первичный смещенный в междоузелье атом, значительно превосходит E_d , такой атом в свою очередь может при движении генерировать пары Френкеля вдоль своей траектории и т. д. Результатом каскада соударений является образование дефектных рауупорядоченных областей — радиационных кластеров с характерным линейным размером $\sim 10^{-8}$ – 10^{-5} см. При этом концентрация компонентов пар Френкеля в кластере может достигать 10^{21} – 10^{22} см $^{-3}$. При ионной имплантации (энергия ионов $\sim 10^2$ кэВ) локализация кластеров в тонких слоях, определяемых пробегом ионов ($\sim 10^{-4}$ см), ведёт к образованию слоёв с большей концентрацией дефектов (см. *Ионная бомбардировка*).

Во мн. случаях образование пар Френкеля и кластеров является лишь первой стадией формирования устойчивых Р. д. После возникновения вакансий и междоузельные атомы частично рекомбинируют, частично начинают движение по мишени, вступая в т. н. квазиким. реакции друг с другом и с др. дефектами структуры мишени (примесными атомами, дислокациями или границами раздела фаз).

Типы и концентрации устойчивых Р. д. определяются как условиями облучения, так и свойствами самих твёрдых тел. При этом для лёгких частиц и фотонов не слышком высоких энергий наиб. характерно образование устойчивых точечных дефектов (вакансий, междоузельных атомов, дивакансий, комплексов компонентов пары Френкеля с примесными атомами и т. п.). При облучении нейтронами устойчивый кластер представляет собой дивакансионное ядро, окружённое примесно-дефектными комплексами. При ионной бомбардировке плотность точечных дефектов в кластере больше, чем при нейтронной, и она тем выше, чем больше масса иона. При этом важную роль в формировании устойчивых кластеров играет процесс пространственного разделения вакансий и междоузельных атомов, предшествующий стадии квазиким. реакций. В силу этого устойчивые кластеры, возникающие при ионной бомбардировке, имеют более сложную структуру и состоят из вакансионных комплексов с разл. числом вакансий, примесно-дефектных комплексов, а также атомов внедрённой примеси. При облучении кристаллов тяжёлыми ионами устойчивые кластеры представляют собой локальные аморфные области.

Р. д. — метастабильные образования, их концентрация и природу можно изменить нагревом (термич. отжиг дефектов). Такая термообработка иногда может сопровождаться полным восстановлением исходной структуры. В то же время в зависимости от условий отжига (темпера, скорость её изменения, время, газовая среда, характер возбуждения электронной системы атомов и дефектов) квазиким. реакции могут сопровождаться появлением новых типов дефектов. Напр., типичный для технологии микроэлектроники отжиг бездислокационного Si, имплантированного большими дозами ионов Р, сопровождается образованием дислокаций, плотность к-рых особенно высока, если нагрев осуществляется в окислит. атмосфере. При термич. отжиге Р. д. приобретают энергию, достаточную для разрыва связи между ними, миграции освобождёвшихся частиц и протекания реакций с их участием.

В качестве источника энергии при отжиге иногда могут служить облучение (радиацион. отжиг). При этом механизмы радиац. отжига могут быть обусловлены как повышением темп-ры мишени (радиацион. разогрев), так и реакциями взаимодействия рождающихся компонентов пар Френкеля с ранее образовавшимися Р. д. Примером радиац. отжига является стимулированная ионами кристаллизация, благодаря к-рой аморфный слой, образующийся в кристаллич. полупроводниках в результате ионной бомбардировки, вновь кристаллизуется при продолжении облучения.

Взаимодействие излучений с твёрдым телом сопровождается рядом т. н. радиац. эффектов. В их числе: *растяжение*; изменение коэф. диффузии; удаление атомов с облучаемой поверхности; т. н. трансмутация, легирование (образование примесных атомов в результате ядерных реакций); ионный синтез (хим. реакция, приводящая к образованию новых соединений, в имплантированных химически активных ионами объектах в процессе облучения или последующего отжига).

Генерация Р. д. в твёрдых телах материалах сопровождается изменением их свойств. Так изменяются форма и размеры облучённых образцов (радиацион. распухание), причём анизотропный характер этих изменений зависит как от концентрации, так и от конфигурации Р. д. Изменяются механич. свойства твёрдых тел, что проявляется в увеличении предела текучести пластичных материалов, векром повышении модуля упругости, ускорении ползучести. Накопление Р. д. изменяет степень упорядоченности структуры сплавов и ускоряет фазовые переходы. Электропроводность облучённых тел изменяется прежде всего из-за появления заряд. дефектов. Особенно сильно это проявляется в полупроводниках, где Р. д. не только выступают как центры *рассеяния носителей заряда*, но способны изменить концентрацию и природу осв. носителей заряда. Нейтральные дефекты также влияют на проводимость, т. к. являются центрами рассеяния носителей. Для оптич. свойств характерно появление новых областей поглощения в разл. спектральных областях (см. *Центры окраски*). Специфически влияет облучение на поверхность твёрдых тел, не только вызывая образование иных, не свойственных объёму дефектных структур, но и изменяя физ.-хим. свойства поверхности (напр., кинетику окисления и адсорбции).

Ионизируемые Р. д. изменяя свойства материалов нередко затрудняют их практич. использование. Так, изменение механич. свойств, однородности состава и геом. размеров конструкц. элементов ограничивает срок работы *ядерных реакторов*. Особенно сильно влияет радиация на полупроводниковые материалы и приборы. В силу высокой чувствительности элетрич. характеристик полупроводников к появлению малой концентрации Р. д. облучение полупроводников даже при низких дозах радиации может сопровождаться существен. изменениями параметров полупроводниковых приборов.

В то же время образование Р. д. в твёрдых телах, особенно в сочетании с др. воздействиями (с изменением темп-ры, механич. нагрузки, элетрич. поля, освещения), позволяет направленно регулировать свойства твёрдых телых материалов.

Примерами применений радиац.-технол. процессов, осн. на использовании свойств Р. д., являются повышение коррозионной стойкости металлов под влиянием ионной имплантации, деформат. упрочнение облучённых ионных кристаллов, ускоренная полимеризация пластмасс, нейтронное трансмутация, легирование Si и др. Совершенство методов для создания материалов, устойчивых к облучению, а также для придания материалам нужных свойств под действием облучения составляют предмет радиац. материаловедения.

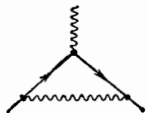
Лит.: Келдыш В., Радиационное повреждение твёрдых тел, пер. с англ., М., 1970; Физические процессы в облучённых полупроводниках, под ред. Л. С. Смирнова, Новосибир., 1977, В. Н. Мордович.

РАДИАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ — поправки *возмущений теории* к амплитудам разл. процессов в *квантовой теории поля* (КТП), обусловленные рождением и уничтожением виртуальных частиц.

Вычисление Р. п. к гл. эл.-динамик. процессам было первой задачей после построения осн. принципов *квантовой электродинамики* (КЭД) в 30-х гг. Возникающие при расчётах бесконечности (см. *Ультрафиолетовые расходимости*) устраняются после перенормировок. Совр. метод вычисления Р. п. основан на применении релятивистской инвариантной теории возмущений, созданной в кон. 40-х гг. в работах Р. Фейнмана (R. Feynman), Дж. Швингера (J. Schwinger), С. Томонага (S. Tomonaga), Ф. Дайсона (F. Dyson). Чаще всего используются наглядный метод *Фейнмана диаграмм*.

Исторически нач. импульс развитию совр. КТП дали опыты У. Лэмба (W. Lamb) и Р. Ризерфорда (R. Retherford) в 1947 по измерению расщепления $2S_{1/2}$ и $2P_{1/2}$ уровней атома водорода, вырожденных в релятивистской квантовой механике с учётом тонкого и сверхтонкого расщеплений. Оказалось, что в действительности вырождения нет — уровень $2P_{1/2}$ на 1000 МГц ниже $2S_{1/2}$. Первые теоретич. расчёты были выполнены в том же году Х. Бете (H. Bethe). С полной последовательностью Р. п. учтены Н. Кроллом (N. Kroll) и У. Лэмбом, а также Дж. Френчем (J. French) и В. Вайскопфом (V. Weisskopf) в 1949 — после рождения совр. КЭД. Осн. вклад в это расщепление (*ламбовский сдвиг*) вносит поправка и вершинной ф-ции; соответствующая диаграмма Фейнмана имеет вид, изображённый на рис. 1 (где сплошные линии отвечают электрону, волнистые — фотону).

Рис. 1.



Совр. теоретич. расчёты учитывают большое число диаграмм и приводит к величине расщепления $\Delta E_{\text{теор}} = \mathcal{E}(2S_{1/2}) - \mathcal{E}(2P_{1/2}) = 1057,910$ МГц [Г. У. Эрикссон (G. W. Erickson), 1974] или $1057,884(14)$ МГц [П. И. Мор (P. I. Mohr), 1975]. Кроме того, в расчётах учитывались эффекты следующих порядков по константе связи, были учтены также эффекты конечных размеров ядра. Эксперим. данные находятся в прекрасном согласии с теоретич. расчётами: $\Delta E_{\text{эксп}} = 1057,8514(19)$ МГц.

Вычисление вершинной диаграммы позволяет изучить ещё одну важную Р. п. — *аномальный магнитный момент*. Если принять магн. момент фермиона со спином $1/2$, вытекающий из теории Дирака, за единицу, то одноплетевая Р. п. равна $\alpha/2\pi$, где $\alpha \approx 1/137$ — постоянная тонкой структуры, константа связи КЭД. Эта поправка была вычислена впервые Дж. Швингером в 1948, а затем Р. Фейнманом в 1949 с помощью диаграммной техники. Обычно говорят не о самом магн. моменте, а о гиромагнитном отношении g , определяемом как коэф. пропорциональности между магн. моментом μ и спином S , $\mu = g(e/2mc)S$, где e , m — заряд и масса фермиона. В теории Дирака $g = 2$ и Р. п. опясываются величиной $(g - 2)$. Теоретич. расчёт позволяет учесть поправки порядка α^2 . При этом получают разные значения для электрона и мюона, что связано с зависимостью результата от массы фермиона. Теоретич. результат для электрона:

$$\left(\frac{g-2}{2}\right)_{\text{теор}} = \frac{\alpha}{2\pi} - 0,328478945\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 + 1,47562(56)\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^3 - 1,47(15)\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^4 = 1159652164(108) \cdot 10^{-12};$$

эксперим. значение:

$$\left(\frac{g-2}{2}\right)_{\text{эксп}} = 1159652188,4(4,3) \cdot 10^{-12}$$

(по данным 1988).

Учёт поправок 4-го порядка по α потребовал вычисления почти 900 диаграмм Фейнмана. Для дальнейшей повышения точности необходимо учитывать поправки, связанные со *слабым взаимодействием*, вклад к-рых имеет порядок 10^{-13} .

При вычислении аномального магн. момента мюона необходимо учитывать, хотя и приближённо, поправки 4-го порядка по α (из-за большого фактора, пропорционального отношению масс мюона и электрона). Кроме этого, относительно велик вклад в величину $(g_\mu - 2)$ адронных поправок из-за адронной перенормировки фотонного пропэгатора. Чисто электродинамич. вклад есть

$$\left(\frac{g_\mu-2}{2}\right)_{\text{эл}} = \frac{\alpha}{2\pi} + 0,765858(10)\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 + 24,073(11)\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^3 + 140(6)\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^4 = 11658480(3) \cdot 10^{-10},$$

а адронная поправка равна $702(19) \cdot 10^{-10}$, так что полное теоретич. значение

$$\left(\frac{g_\mu-2}{2}\right)_{\text{теор}} = 11659202(20) \cdot 10^{-10}$$

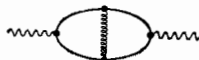
находится в прекрасном согласии с эксперим. значением $(g_\mu - 2)_{\text{эксп}} = 1165922(9) \cdot 10^{-9}$. Оценка величины вклада слабого взаимодействия даёт $2 \cdot 10^{-9}$, что меньше точности в теории и эксперименте.

Ещё одна важная Р. п. — поправка к отношению сечений электрон-позитронной аннигиляции в адроны и мюоны:

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{адроны})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)}.$$

Из квантовой хромодинамики (КХД) следует, что для этого отношения в области применимости теории возмущений осн. поправки связаны с обменами *глюонами*, в частности, гл. поправка определяется двухпетлевой диаграммой (рис. 2) [спиральные линии здесь изображают глюоны, прямые — кварки, внешние (волнистые) —

Рис. 2.



фотона]. Вычислены вклады четырёхпетлевых диаграмм при условии малости масс кварков, так что оканчат. выражение для R имеет вид

$$R = 3 \sum_i Q_i^2 \left[1 + \frac{\alpha_s}{\pi} + 1,41 \left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^2 + 64,7 \left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^3 \right] - \left(\sum_i Q_i \right)^2 1,679 \left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^3,$$

где сумма берётся по всем типам кварков, Q_i — величины кварковых зарядов (заряд электрона принят за единицу) и α_s — константа связи КХД.

Помимо процесса электрон-позитронной аннигиляции а адроны при высокой энергии, теория возмущений может применяться в КХД при изучении *глубоко неупругих процессов*, при этом вычисление Р. п. позволяет обнаружить логарифмич. отклонение от скейлинга Бёрнена (см. *Масштабная инвариантность*) в этих процессах.

В теории электрослабого взаимодействия Вайнберга — Гашоу — Салама помимо вычисления Р. п. к наблюдаемым процессам, напр. к бета-распаду или распаду мюона, имеет смысл говорить также о вычислении поправок к осн. параметрам теории — к массам промежуточных векторных бозонов и Вайнберга углу, определяющему интенсивность нейтральных токов. Это связано с тем, что теория предсказывает определ. отношение между разными параметрами, к-рые измеряются в независимых экспериментах. Наиб. удобной параметризацией является следующая. Для угла Вайнберга θ_W

$$\sin^2\theta_W = \sin^2\theta_0 + \Delta S^2,$$

где $\sin^2\theta_0 = 0,242(6)$ — значение, полученное из эксперим. данных по глубоко неупругому рассеянию в преобладании всеми Р. п. к заряженным (см. Заряженный ток) и нейтральным током, а ΔS — величина Р. п. Для массы т-кварка 45 ГэВ и массы Хиггса бозона 100 ГэВ $\Delta S^2 = -0,009(1)$.

Для масс промежуточных векторных бозонов W^\pm, Z используется параметризация:

$$M_W = \frac{A^0}{\sin\theta(1-\delta_W)^{1/2}}, \quad M_Z = \frac{M_W}{\cos\theta_W},$$

где $A^0 = (\pi\alpha/\sqrt{2}G_F)^{1/2} = 37,281$ ГэВ, G_F — фермиевская константа слабого взаимодействия; величина δ_W описывает вклад Р. п. в массы, возникающий при вычислении поправок к процессам глубоко неупругого рассеяния, к слабому распаду мюона (при определении G_F) и к поляризац. операторам фотона и промежуточных векторных бозонов. При упоминавшихся массах t-кварка и хиггсовского бозона теоретич. предсказание для величины δ_W составляет

$$\delta_W^{\text{теор}} = 0,106(4),$$

эксперим. значение:

$$\delta_W^{\text{эксп}} = 0,112(37).$$

Т. о., с уровнем достоверности 90% эксперим. данные подтверждают существование Р. п. к осн. соотношению для масс промежуточных векторных бозонов и угла смешивания Вайнберга.

Весьма существен. роль могут играть Р. п. и в разл. распадах. Напр., распады хиггсовских бозонов могут определять однопетлевые, а не древесные диаграммы, т. к. однопетлевые диаграммы в этом случае не малы, поскольку содержат большую константу связи хиггсовского бозона с тяжёлыми виртуальными кварками (b, t, \dots). Также важна роль Р. п. в слабых радиац. распадах гиперонов типа $\Sigma^+ \rightarrow p, \Xi^- \rightarrow \Sigma^- \gamma$ и др. Большой вклад в эти процессы вносят графики типа рис. 3 (где сплошная линия изображает барионы, волнистая линия — фотон, а штриховая — пион или каон).



Рис. 3.

Важность таких диаграмм связана с тем, что при интегрировании по импульсам виртуальных частиц в петле возникает большой логарифм $\ln(M_B/m_s)$, где M_B, m_s — массы бариона и пиона. Существует много и др. распадов, в к-рых Р. п. также чрезвычайно существенно.

Важна роль Р. п. и в моделях великого объединения теорий взаимодействия (GUT). В частности, в модели,

осн. на группе $SU(5)$, масса великого объединения в орбитальном приближении не зависит от числа поколений фермионов, что связано с одинаковым вкладом в бета-функцию для разных зарядов. Однако на двухпетлевом уровне (т. е. при учёте Р. п. следующего за главным приближением) такая зависимость появляется. Кроме того, важна их роль и при получении синуса угла Вайнберга из модели великого объединения. Так, для $SU(5)$ -модели учёт поправок изменяет затронутое значение квадрата синуса угла смешивания 0,237, следующее из теоретико-групповых свойств модели в нулевом приближении, на более близкое к эксперименту значение 0,228. Точнее,

$$\sin^2\theta_W(M_W) = 0,237^{+0,003}_{-0,004} - \frac{1}{5} \frac{\alpha(M_W)}{\pi} \ln \frac{M_{GUT}}{M_W};$$

при этом масса великого объединения M_{GUT} порядка $5 \cdot 10^{16}$ ГэВ.

Помимо поправок в КЭД, КХД и теории электрослабого взаимодействия интерес представляет вычисление Р. п. в теории гравитации, однако пока этот вопрос не является строго поставленным, поскольку в квантовой теории гравитации, в отличие от теории калибровочных полей, вычисление Р. п. невозможно — эта теория неперенормируема. Построение квантовой теории гравитации (в будущем) позволит однозначно вычислять квантовые поправки к любому процессу.

Лит.: Л. В. Г. Р. Уэллс и Д. В. The implications of QED theory for fundamental constants, a кн.: Proc. of the Second Intern. Confer. on precision measurement and fundamental constants, National Bureau of Standards, Gaithersburg, Wadsworth, 1982. М. И. Косов и К. Зюбер, Ж.-Б. Квантовая теория поля, пер. с англ., т. 1, М., 1984; Kinoshita T., Nishizawa O. kamo T. Y., Improved theory of the muon anomalous magnetic moment, «Phys. Rev. Lett.», 1984, v. 52, № 9, p. 717; A. M. L. и др., Comprehensive analysis of data pertaining to the weak neutral current and the intermediate — vector-boson masses, «Phys. Rev.», 1987, v. 36 D, № 5, p. 1385; Gorishny S. G., Kataev A. L., Larin S. A., Next-next-to-leading α_s^2 QCD correction to $\sigma_{\text{had}}(e^+e^- \rightarrow \text{hadrons})$: analytical calculation and estimation of the parameter A_{had}^2 , «Phys. Lett.», 1988, v. 212 B, № 2, p. 238; Kinoshita T., Accuracy of the fine-structure constant, «IEEE Trans. Instrum. Meas.», 1989, v. 38, № 2, p. 172.

РАДИАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ — энергия, теряемая заряд. частицей, движущейся в веществе, за счёт эл. маг. излучения. Испускание фотонов обусловлено рассеянием частиц в кулоновском поле ядер. Кулоновское поле тормозит частицу, и она теряет часть энергии, излучая фотоны. Возникающее при этом излучение наз. тормозным, а сам процесс — радиацион. торможением. Р. п. зависит от заряда ядер вещества Z . Тяжёлые материалы обладают большей тормозной способностью. С др. стороны, ускорение частицы обратно пропорционально её массе m , т. е. при одном и том же Z навб. Р. п. будут испытывать электроны. Сущест. роль в процессе радиац. торможения играет расстояние частицы от ядра в момент испускания фотона. На больших расстояниях от ядра его поле можно рассматривать как поле точечного заряда, но если это расстояние больше ср. радиуса орбит атомных электронов, то необходимо учитывать экранирование поля ядра электронами. Если расстояние, на к-ром происходит испускание фотона, мало, то поле ядра уже не может рассматриваться как поле точечного заряда.

Осн. характеристики тормозного излучения даёт классич. электродинамика [1]. Квантовая теория обеспечивает более точные количеств. результаты [2—4]. Вероятность излучения электронами, имеющими энергию ϵ , фотона с энергией ϵ' даётся ф-лой

$$W(\epsilon, \epsilon') d\epsilon' = 4\pi\alpha Z^2 r_e^2 \frac{d\epsilon'}{\epsilon} \left\{ \left[1 + \left(1 - \frac{\epsilon'}{\epsilon} \right)^2 \right] \Phi_1 - \left[1 - \left(\frac{\epsilon'}{\epsilon} \right)^2 \right] \Phi_2 \right\}, \quad (1)$$

Здесь λ — число атомов вещества в 1 см^3 , $\alpha = 1/137$; $r_e = 2,82 \cdot 10^{-13}$ см. Ф-ции Φ_1, Φ_2 описывают экраниро-

вание кулоновского поля ядра атомными электронами, к-рое характеризуется параметром

$$\gamma = 100 \frac{mc^2}{\mathcal{E}} \cdot \frac{\mathcal{E}'}{\mathcal{E} - \mathcal{E}'} \cdot Z^{-1/2},$$

где m — масса электрона. При $\gamma \gg 1$ экранирование отсутствует, тогда

$$\Phi_1 = \ln \left(\frac{2\mathcal{E}}{mc^2} \cdot \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}'}{\mathcal{E}'} \right) - \frac{1}{2}; \quad \Phi_2 = -\frac{2}{3} \Phi_1.$$

Когда $\gamma = 0$, имеет место полное экранирование, при к-ром

$$\Phi_1 = \ln(191Z^{-1/2}); \quad \Phi_2 = -\frac{2}{3} \ln(191Z^{-1/2}) + \frac{1}{9}.$$

В промежуточных случаях выражения для Φ_1 и Φ_2 становятся более сложными [3].

Р. п. на пути x для электрона можно определить, интегрируя выражение (1) по энергии фотона:

$$-\left(\frac{d\mathcal{E}}{dx}\right) = \int_0^{\mathcal{E}} \sigma' W_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}') d\mathcal{E}'. \quad (2)$$

В случае $\gamma \approx 0$ и высоких энергий \mathcal{E} получаем

$$-\left(\frac{d\mathcal{E}}{dx}\right) = 4n\alpha Z^2 r_0^2 \left[\ln(191Z^{-1/2}) + \frac{1}{8} \right].$$

При этом отност. потери энергии $(-d\mathcal{E}/dx)/\mathcal{E}$ являются пост. величиной для данного вещества. При малых энергиях отност. Р. п. растут логарифмически с ростом \mathcal{E} , что следует из (2):

$$-\left(\frac{d\mathcal{E}}{dx}\right) = 4n\alpha Z^2 r_0^2 \left(\ln \frac{2\mathcal{E}}{mc^2} - \frac{1}{3} \right).$$

В случае полного экранирования

$$W_{\mathcal{E}} d\mathcal{E}' = \frac{1}{x_0} \frac{d\mathcal{E}'}{\mathcal{E}'},$$

где x_0 — т. н. радиац. длина, определяемая выражением

$$\frac{1}{x_0} = 4n\alpha Z^2 r_0^2 \ln(191Z^{-1/2}).$$

Для вещества сложного хим. состава

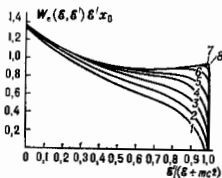
$$\frac{1}{x_0} = \sum_i f_i / x_{0i},$$

где x_{0i} — радиац. длина i -го компонента, f_i — его отност. вес. Выражение для отност. Р. п. электрона на радиац. единице длины имеет вид $(1/\mathcal{E})(d\mathcal{E}/dx) = 1$. Интегрирование этого выражения даёт величину энергии электрона после прохождения слоя вещества толщиной x (в радиац. единицах длины):

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \exp(-x).$$

Энергетич. спектр фотонов тормозного излучения непрерывен (рис.). Число фотонов уменьшается с

Дифференциальное сечение радиационного торможения электронов в Рб при $\mathcal{E}/mc^2 = 10^1(1)$, $2 \cdot 10^1(2)$, $4 \cdot 10^1(3)$, $10^2(4)$, $2 \cdot 10^2(5)$, $10^3(6)$, $10^4(7)$, ∞ (8).



ростом энергии фотона. Макс. энергия фотона равна энергии электрона. Угл. распределение тормозных фотонов имеет максимум в направлении движения электрона. Ср. угл. испускания тормозных фотонов определяется выражением

$$\bar{\theta} \approx \frac{mc^2}{\mathcal{E}} \ln \frac{\mathcal{E}}{mc^2}.$$

При торможении электронов в монокристаллах Р. п. могут зависеть от направления движения электрона относительно кристаллографич. осей. При определ. условиях имеют место когерентное тормозное излучение и излучение навалерованных частиц. Энергетич. спектр тормозных фотонов при этом отличен от спектра, возникающего при торможении электронов в аморфном веществе [5].

К Р. п. можно отнести также потери за счёт Черенкова — Вавилова излучения, испускаемого заряд. частицами, движущимися в веществе со скоростями, превышающими фазовую скорость света в данной среде, и за счёт т. н. переходного излучения, испускаемого заряд. частицей при пересечении границы раздела сред, имеющих разные значения диэлектрич. проницаемостей.

Движение электронов в вакууме может также сопровождаться Р. п. энергии, если они движутся в магн. поле [6]. Эти потери энергии неизбежны в циклот. синхротроне (см. Синхротронное излучение).

Лит.: 1) Ферми Э., Ядерная физика, пер. с англ., М., 1951; 2) Габеллер В., Квантовая теория излучения, пер. с англ., М., 1968; 3) Белицкий И. С. З., Лавинные процессы в космических лучах, М.—Л., 1948; 4) Россси В., Частицы больших энергий, пер. с англ., М., 1955; 5) Review of particle properties, Phys. Lett., 1958, т. В 204; 6) Базылев В. А., Желего И. К., Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях, М., 1987.

А. С. Велюсов.
РАДИАЦИОННЫЙ ЗАХВАТ — ядерная реакция, в к-рой влетающая частица захватывается ядром-мишенью, а энергия возбуждения образующегося составного ядра излучается в виде γ -квантов (иногда — конверсионных электронов; см. Конверсия внутренняя). Р. з. — преобладающий процесс взаимодействия с ядрами для нейтронов, для др. частиц он играет существенно меньшую роль.

Р. з. медленных нейтронов с энергией \mathcal{E} в осн. идёт через резонансное образование состояний составного (компаунд) ядра при $l = 0$ (см. Нейтронная спектроскопия). Сечение Р. з. σ , описывается Брейта — Вигнера формулой

$$\sigma_T = \pi \left(\frac{\lambda}{2\pi} \right)^2 \frac{g_{\Gamma_0}^2 \Gamma_{\Gamma_0}}{(\mathcal{E} - \mathcal{E}_0)^2 + \Gamma^2/4}. \quad (1)$$

Здесь Γ — полная ширина нейтронного резонанса, Γ_0 , Γ_{Γ_0} — нейтронная и радиац. пирины нейтронного резонанса, \mathcal{E}_0 — кинетич. энергия нейтрона в максимуме резонанса, λ — длина волны нейтрона, g — т. н. спиновый фактор, зависящий от спиновых состояний исходного и составного ядер. Для тепловых нейтронов Р. з. обусловлен вкладом ближайших состояний составного ядра, в т. ч. состояний с энергией меньше энергии связи нейтрона. Сечение Р. з. тепловых нейтронов

$$\sigma_T = 6,5 \cdot 10^{-12} \mathcal{E}^{-1/2} \sum_i \left(\frac{g_{\Gamma_0}^2 \Gamma_{\Gamma_0}}{\Gamma_0^2} \right)_i \text{ см}^2, \quad (2)$$

где $\Gamma_0 = \Gamma_n \sqrt{1/\mathcal{E}}$. Суммирование ведётся по всем резонансам i), приближение справедливо при $|\mathcal{E}_0| \gg \mathcal{E}$; $|\mathcal{E}_0| \gg \Gamma$. Множитель $\mathcal{E}^{-1/2}$ в (2) обусловливает т. н. закон $1/v$ в сечении Р. з. медленных нейтронов. Для ядер, у к-рых имеется резонанс при низкой энергии нейтронов ($\mathcal{E} \leq 0,3$ эВ), сечение велико и достигает 10^4 — 10^6 бари (напр., у ^{133}Cs $2 \cdot 10^4$, у ^{157}Gd $2,5 \cdot 10^6$).

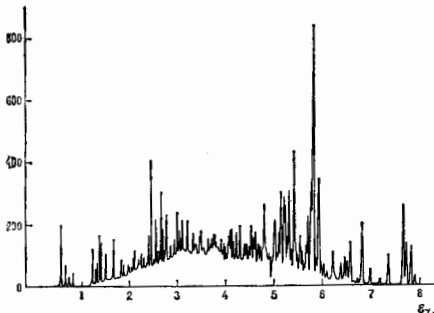
Для Р. з. быстрых нейтронов становится существенными нейтроны с $l \geq 1$. Однако усреднённое сечение убывает с ростом энергии \mathcal{E} за счёт уменьшения λ .

С увеличением массового числа A ядра сечения $P. з.$ возрастает. Для $\sigma = 1$ МэВ $\sigma(A = 50-100) \approx 3-10$ миллибарн; $\sigma(A = 150-240) \approx 80-200$ миллибарн. С увеличением σ до 5 МэВ сечение σ уменьшается примерно в 5 раз. Приведённые значения σ являются приближёнными, т. к. σ меняется в неск. раз при переходе от ядра к ядру.

При захвате нейтрона образовавшееся составное ядро возбуждено до энергий $E^* = E_{св} + E_n$, где $E_{св} \approx 6-8$ МэВ — энергия связи нейтрона в ядре. Возбуждение у большинства тяжёлых и средних ядер снимается за счёт испускания каскада γ -квантов, имеющих сложный спектр из-за разнообразия переходов между уровнями ядра ниже $E_{св}$ (рис.). Лёгкие и мажические ядра имеют меньшую плотность уровней, а потому и более простой γ -спектр. Измерение γ -спектра позволяет получить информацию о возбуждённых состояниях ядра.

Р. з. нейтронов приводит к образованию ядер с массовым числом $A + 1$. Это используется для получения радиоизотопов. Напр., γ -источник ^{60}Co образуется при нейтронном облучении в ядерном реакторе природного ^{59}Co . Р. з. используется для детектирования нейтронов (см. Нейтронные детекторы).

Р. з. протонов преишествует кулоновский барьер ядра. С увеличением энергии протона E_p прозрачность барьера $D(E_p)$ возрастает и Р. з. протонов становится



Аппаратурный спектр γ -квантов радиационного захвата ^{144}Cs β , ^{144}Cs . Энергии E_γ даны в МэВ.

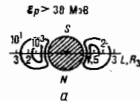
заметным. Увеличение A сопровождается уменьшением $D(E_p)$, и сечение Р. з. падает. Для налетающих частиц с зарядом $Z > 1$ Р. з. практически не наблюдается.

Лит. см. при ст. Ядерные реакции. Л. Б. Пихальмер. РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС — область околоземного (околопланетного) пространства с интенсивными потоками энергичных заряд. частиц. Р. п. Земли открыт в 1958 в результате полётов первых ИСЗ. Детекторы заряд. частиц, регистрировавшие поток космических лучей вне атмосферы, обнаружили, что потоки электронов и протонов с энергиями от неск. десятков кэВ до сотен МэВ на неск. порядков превышают фоновый поток космич. лучей в окрестности Земли. Позже в Р. п. Земли обнаружены α -частицы, ионы кислорода и тяжёлые ионы.

Геомагн. поле экранирует поверхность Земли от потоков солнечных и галактич. космич. лучей и является ловушкой для заряд. частиц (см. Геомагнитная ловушка). Концентрация захваченных в подобную ловушку частиц определяется интенсивностью источника этих частиц и их временем жизни, или, др. словами, потерями. Т. к. диапазон энергий захваченных частиц (т. е.

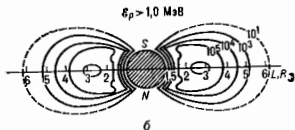
частич, траектории к-рых в преобладании процессами потерь бесконечно долго остаются в области Р. п.) весьма широк, то оказываются существенно различными источники частиц равных энергий и наиб.эфф. механизмы потерь. Осн. источником частиц самых высоких энергий является распад нейтронов альbedo космич. лучей (нейтронов, образующихся при взаимодействии космич. лучей с плотными слоями атмосферы). Частицы меньших энергий, вносящие наиб. вклад в плотность энергии Р. п., появляются в результате процессов переноса и ускорения маловысвергичной магнитоферной плазмы, к-рая, в свою очередь, восполняется за счёт истечения ионосферной плазмы вдоль силовых линий магн. поля в полярных областях Земли. Др. источником магнитоферной плазмы являются частицы солнечного ветра, проникающие внутрь магнитоферы Земли. Во время интенсивных магнитосферных возмущений — магнитосферных суббурь и магн. бурь (см. Магнитные вариации) — особенно велика роль ионосферного источника.

В 1980-х г.г. появилась гипотеза о «крутовороте» плазмы в магнитофере Земли. Эксперим. подтверждение этой гипотезы получено при измерениях ионного состава Р. п. — среди энергичных частиц зарегистрирована значит. доля ионосферных ионов (ионов кислорода и молекулярных ионов). Хотя нм. аспекты процессов ускорения и переноса частиц в магнитофере недостаточны ясно, в первом приближении Р. п. можно считать промежуточным резервуаром накопления энергичных частиц, перемещающихся по эвергетич. шкале в процессе «крутоворота». Предполагается, что «крутоворот» плазмы в магнитофере Земли происходит по следующей схеме. В полярных областях вдоль открытых силовых линий геомагн. поля, уходящих в удалённые области магнитоферы, ионосферные ионы и электроны с энергией неск. эВ (превышающей их тепловую энергию) «испаряются» из плотных слоёв атмосферы, преодолевая гравитат. притяжение Земли (т. н. полириный эффект). Попадая в плазменный слой хвоста магнитоферы, эти частицы ускоряются до энергий порядка неск. кэВ и вовлекаются в коллективное движение плазмы к Земле. На внеш. границе Р. п. (на геосинхр. расстояниях $6-10 R_E$, R_E — радиус Земли) большие квазистационарные электрич. поля и сильно неоднородные магн. поля увеличивают энергию частиц ещё на один-два порядка. Далее, перемещаясь ближе к Земле, в район максимума потоков частиц Р. п. ($2-5 R_E$), в результате рассеяния на колебаниях электрич. и магн. полей, частицы попадают в область всё более сильного магн. поля, испытывая индуц. ускорение вплоть до энергий в сотни МэВ. Те же процессы рассеяния, к-рые приводит к радиальному перемещению частиц к Земле, обуславливают их попадание в конус потерь (см. Магнитные лопушки). Он определяется соотношением между полем в вершине силовой линии (в экваториальной плоскости) и полем вблизи торца геомагн. лопушки (в верх. слоях атмосферы). Частицы, у к-рых достаточно велика продольная (по отношению к магн. полю) компонента скорости при движении вдоль силовой линии, попадают в плотные слои атмосферы. Здесь они сталкиваются с ионами или нейтральными атомами и тормозятся, «теряясь» среди тепловых ионов. После переноса в полярные области заряд. частицы готовы вновь «стать» полярным ветром и начать новый цикл. Помимо высylation в верх. атмосферу др. механизмом потерь является перезарядка энергичных частиц (см. Перезарядка ионов) на нейтральных атомах экзосферы. Этот процесс особенно важен для долгоживущих энергичных частиц. В целом различия в механизмах ускорения и потерь разных составляющих Р. п. — электронов, протонов и др. частиц — настолько



велики, что делают условным их объединение единым термином частицы Р. п.

Удержание заряд. частиц в Р. п. осуществляется геомагн. полем. В первом приближении его можно считать дипольным. Траектория заряд. частицы в дипольном поле может рассматриваться как суперпозиция трёх циклич. движений: вращения вокруг силовой



линии магн. поля, осциллирующей вдоль силовой линии между точками отражения (расположенными симметрично относительно геомагн. экватора) и азимутального дрейфа вокруг Земли. Для описания пространственного распределения частиц в Р. п. используют координаты L и B . Они имеют смысл геоцентрич. экваториального расстояния до силовой линии, вокруг к-рой частица совершает циклотронное вращение (L), и напряжённости магн. поля (B) в точке отражения, где продольная скорость частицы обращается в ноль, меняя свой знак. При перемещении от периферии в глубь магнитосферы интенсивность потоков частиц возрастает до некоего максимума и затем быстро падает. Чем выше энергия частиц, тем ближе к Земле расположен максимум интенсивности. Для интенсивности потока электронов характерно двукратное распределение по L . Поэтому выделяют внутр. и внеш. Р. п. электронов с зазором на $L = 2-3 R_3$. Иногда употребляют понятия внутр. и внеш. Р. п. протонов. Такое разделение условно, поскольку распределение протонов данной энергии по L имеет один максимум. Теоретически профиль интенсивности потока частиц получают как результат пространственной диффузии частиц, диффузии и переноса частиц в пространств. скоростей. Механизмами, обеспечивающими стохастизацию траекторий частиц, служат рассеяние на волнах и на вращающихся скачках магн. п. электр. полей, обусловленных резкими изменениями параметров плазмы солнечного ветра на фронтах межпланетных ударных волн. Копулирующим механизмом стохастизации может быть т. в. динамич. хаос, связанный с величайшими резонансами между осцилляциями по разл. степеням свободы. Существует достаточно разработанная теория диффузии частиц в фазовом пространстве. Построены модели взаимодействия частиц с разл. модами колебаний, наблюдаемыми в магнитосфере. Для подобного взаимодействия характерны нелинейные процессы, связанные с раскачкой плазменных неустойчивостей. Как правило, теоретич. модели хорошо описывают усреднённые во времени профили интенсивности частиц. На рис. а и б изображены изолинии наблюдаемой интенсивности потоков ($\text{см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$) протонов характерных энергий $E_p(S$ и N — южный и северный магн. полюсы Земли). Нестационарные процессы в детальной пространственной структуре потоков частиц описаны лишь фрагментарно. Требуют дальнейших эксперим. исследований и теоретич. анализа сильные вариации потоков частиц в Р. п. во время ижекции в период магнитосферных суббур и магн. бур.

Помимо Земли Р. п. обнаружены у Юпитера, Сатурна и Урана, обладающих сильным магн. полем. Они обнаружены по регистрируемому на Земле дециметровому и километровому радионезлучению частиц Р. п. Потоки энергичных частиц непосредственно регистрировались при пролётах космич. аппаратов вблизи этих планет. Т. к. магн. поле планет-гигантов близко земного, они имеют более мощные магнитосферы и Р. п. Несмотря на подобие (с учётом соответствующего изменения масштабов) магнитосфер Юпитера, Сатурна и Земли, в

структуре их Р. п. имеются существен. различия. Они обнаружены тем, что спутники Юпитера и Сатурна оказываются в зоне Р. п. Эффект поглощения частиц поверхностью спутника может существенно изменить профиль Р. п. Сильное магн. поле Юпитера значительно ослабляет поток космич. лучей у верх. границы атмосферы. Это делает пренебрежимо малым вклад от распада нейтронов альbedo. В результате энергетич. спектр частиц в Р. п. Юпитера оказывается более «мягким», чем в Р. п. Земли. Большие размеры магнитосферы и мощная энергетика процесса ускорения (до 10^{13} Вт) делают Юпитер самым мощным источником космич. лучей низких энергий (1 — 10 МэВ).

Р. п. представляет собой серьёзную опасность при длит. полётах в околоземном (околопланетном) пространстве. Из-за сильной электризации может выйти из строя бортовая аппаратура. Живые организмы внутри космич. корабля могут получить лучевое поражение. Дим.: Т. В. Р. п. в г. В. А., Динамика радиационных поясов Земли, М., 1968; W i l l i a m s D. J., Ring current and radiation belts, «Rev. Geophys.», 1987, т. 25, № 3, p. 570.

И. И. Алексеев.

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН — совм. воздействие природных и техногенно изменённых радиац. факторов.

Естественный радиационный фон обусловлен в осн. β - и γ -излучениями природного радионуклида ^{40}K и радионуклидами уранового и ториевого радиоактивных рядов, содержащихся в почве, строит. материалах, в теле человека, а также космич. излучением. По данным, к-рые регулярно представляет в ООН Науч. комитет по действию атомной радиации, годовая эфф. эквивалентная доза облучения человека за счёт естеств. Р. ф. составляет в ср. 2,4 мЗв (240 мбэр). На $1/3$ эта доза связана с внутр. воздействием газообразных α -активных продуктов распада радона и торона. При этом вклад продуктов распада радона в дозу почти в 5 раз больше, чем торона. Доза внутр. облучения, обусловленная β - и γ -излучением ^{40}K , к-рый содержится в мягких тканях человека (преим. в мышцах), сравнима с вкладом α -излучения продуктов распада торона и относительно постоянна. Доза за счёт продуктов распада радона и торона подвержена резким изменениям, т. к. на ней к-рые радиоактивности строит. материалов влияют степень обмена воздуха в помещениях.

Внеш. воздействие обусловлено космич. излучением (410 мкЗв) и γ -излучением ^{40}K (150 мкЗв) и радионуклидов ториевого и уранового рядов (160 и 100 мкЗв), содержащихся в почве и строит. материалах. Доза за счёт основных космогенных радионуклидов ^3H , ^6Li , ^{14}C , ^{22}Na , образующихся космич. излучением в верх. слоях атмосферы, мала (15 мкЗв).

Обнаружены области с повышенным Р. ф., в частности высокогорные города Богота, Лхаса, Кито, в к-рых дозы за счёт космич. излучения превышают 1 мЗв, а также песчаные зоны с большой концентрацией минералов, содержащих фосфаты с примесью U и Th, в Индии (шт. Керала) и Бразилии (шт. Эспириту-Санту), участки выхода вод с высокой концентрацией ^{222}Ra в Иране (г. Ромсер) и др. Хотя в нек-рых из этих районов мощность поглощённой дозы в 10^8 раз превышает среднюю по поверхности Земли, обследования населения не выявили сдвигов в структуре заболеваемости и смертности.

Интегральное радиац. воздействие естеств. Р. ф. на население Земли соответствует годовой коллективной эфф. эквивалентной дозе, равной 10^7 чел.Зв (10^8 чел.бэр).

Техногенный радиационный фон обусловлен гл. обр. добычей и сжиганием каменного угля, нефти, газа, др. горючих ископаемых, использованием фосфатных удобрений, добычей и переработкой неуровневых руд, в процессе к-рых происходит перераспределение и концентрирование естеств. радионуклидов. Вклад в техногенный Р. ф. дают также испытания ядерного оружия и ядерная энергетика. При ср. концентрации Ra и Th в дереве 0,2—0,5 Бк/г, в природном гнисе

и обичном бетоне от 1,5 до 10 Бк/кг выявлены стронций, материалы с повшл. уд. активностью ~1200 Бк/кг (Финляндия), 2600 Бк/кг (Швеция), 4600 Бк/кг (США). Коллективная эквивалентная доза за счёт использования фосфогипса в жилищном строительстве достигает $3 \cdot 10^5$ чел.-Зв, за счёт сжигания угля в жилых домах и при использовании угольной золы в строн. материалах — $4 \cdot 10^4$ чел.-Зв, при сжигании угля на электростанциях — $2 \cdot 10^8$ чел.-Зв ($2 \cdot 10^6$ чел.-бэр). Полная ожидаемая доза за год не превышает $5 \cdot 10^6$ чел.-Зв, чему для населения соответствует ср. эквивалентная индивидуальная доза ~100 мкЗв.

Лит.: Сивинцев Ю. В., Естественный радиационный фон. «Атомная энергия», 1988, т. 64, в. 1, с. 46; Доклад Научного Комитета ООН по действию атомной радиации: Приложение. А-облучение за счёт естественных источников ионизирующего излучения. Нью-Йорк, ООН, 1988. Ю. В. Сивинцев.

РАДИЙ (Radium), Ra, — радиоактивный хим. элемент II гр. периодич. системы элементов, ат. номер 88, аналог щёлочно-земельных металлов. Открыт в 1898 П. и М. Кюри (Р. et M. Curie). Все изотопы Р. радиоактивны: α -радиоактивные ^{223}Ra ($T_{1/2} = 11,43$ сут), ^{224}Ra ($T_{1/2} = 3,86$ сут), ^{226}Ra (собственно Р.; $T_{1/2} = 1600$ лет) и β -радиоактивный ^{228}Ra ($T_{1/2} = 5,76$ лет) постоянно присутствуют в земной коре как члены естеств. радиоакт. рядов. Содержание ^{226}Ra составляет ок. 1 г на 3 т урана в урановой руде. Искусственно получают изотопы ^{213}Ra — ^{229}Ra . Электронная конфигурация внеш. оболочки $7s^2$. Энергии последоват. ионизации: 5,279; 10,447; 34,3 эВ. Радиус атома Ra 0,235 нм, радиус иона Ra^{2+} 0,144 нм. Значение электроотрицательности 0,97.

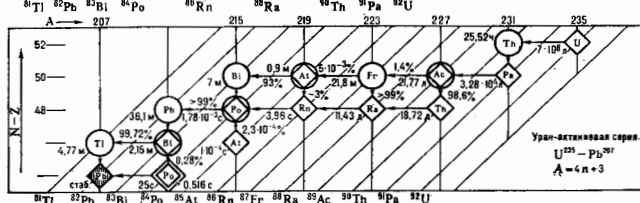
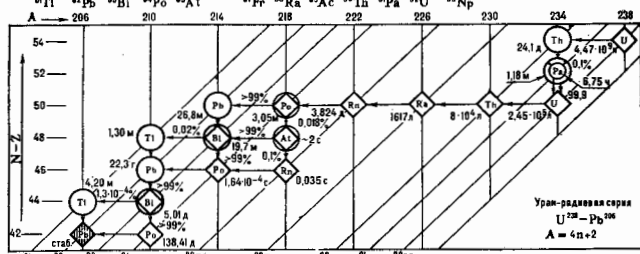
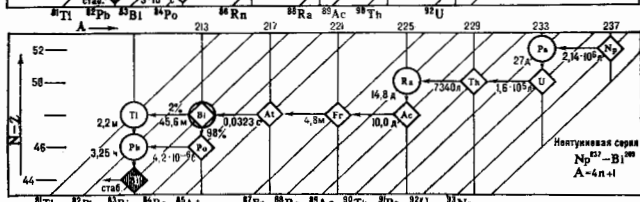
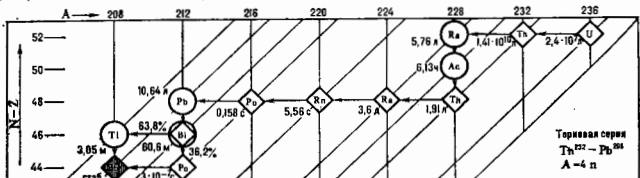
В свободном виде Р. — серебристо-белый блестящий металл с объёмно-центриров. кубич. кристаллич. структурой. Плотн. $5,5$ – $6,0$ г/см³, $t_{\text{пл}} = 700$ – 970 °С (по разным данным), $t_{\text{кип}} = 1440$ – 1500 °С, уд. теплота плавления 37 кДж/кг, теплопроводность 18,6 Вт/(м·К) (при 293 К). Р. и его соединения светятся в темноте.

Химически активен и схож с Ba, в соединениях проявляет степень окисления +2. Р. и его соединения токсичны. Р. использовался в 1900–30-х гг. для исследования радиоактивности; радиоактивность 1 г Р. принималась за единицу

её измерения (кюри). Нынче Р. применяют в осн. в медицинских целях (как источник радона для радонных ванн), в смеси с ^{226}Ra используют в ампульных источниках нейтронов.

Лит.: Погродкин С. А., Либман Э. П., Как добывать советский радий, 2 изд., М., 1977. С. С. Верёвова.

РАДИОАКТИВНОСТЬ (от лат. radio — излучаю + activus — деятельный) — свойство атомных ядер самопроизвольно (спонтанно) изменять свой состав (заряд Z , массовое число A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов. Радиоакт. распад может происходить, если данное превращение энергетически выгодно, т. е. если разность Q между массой исходного ядра и суммарной массой продуктов распада положительна. Нек-рые из существующих в природе ядер радиоактивны, но большинство радиоакт. нукли-



○ β -радиоактивный; ◊ α -радиоактивный

дов получены искусственно в результате ядерных реакций. Искусств. Р. ядер определяет границы (по A и Z) существования в природе радиоуклидов. Ядра, радиоактивные в осн. состоянии, распадаются и в возбуждённых состояниях. При достаточно больших энергиях возбуждения стабильные ядра также становятся радиоактивными. Ниже рассматриваются ядра, радиоактивные в осн. состоянии.

Явление Р. открыто в 1896 А. Беккерелем (А. Becquerel), к-рый наблюдал спонтанное испускание солями U незастоящего излучения. Вскоре Э. Резерфорд (Е. Rutherford) и П. и М. Кюри (Р. et М. Curie) установили, что при радиоакт. распаде испускаются ядра He (α -частицы), электроны (β^- -частицы) и жёсткое эл.-магн. излучение (γ -лучи). В этот период исследователи Р. могли использовать лишь естеств. радиоуклиды, содержащиеся в земных породах в достаточно большом кол-ве. — ^{232}Th , ^{238}U , ^{235}U . С этих радиоуклидов начинаются 3 радиоакт. семейства (радиоакт. ряда), заканчивающихся стабильными изотопами Pb (рис.). В дальнейшем был обнаружен ряд, начинающийся с ^{237}Np , с конечным стабильным ядром ^{209}Bi ; ^{237}Np обнаружен в урановых рудах в соотношении $^{237}\text{Np}/^{238}\text{U} = 1,8 \cdot 10^{-4}$, впоследствии — в ядерных реакторах, где он образуется в результате реакции

$$^{238}\text{U}(n, 2n) ^{237}\text{U} \xrightarrow{\beta^-} ^{237}\text{Np}.$$

Ядра — члены семейства находятся в равновесии между собой, поэтому наряду с долгоживущими родоначальниками существуют и все короткоживущие продукты их распада. Т. к. радиоуклиды открывались как продукты распада U и Th, то им давались названия по месту в радиоакт. ряду, напр. $\text{U}_X, \rightarrow \text{U}_X; \text{Ra} \rightarrow \text{RaE}$.

Распад с вылетом позитронов (β^+ -распад) открыт в 1934 И. и Ф. Жолио-Кюри (I. et F. Joliot-Curie). В 1940 открыт новый тип Р. — спонтанное деление ядер (К. А. Петряк, Г. Н. Флёров). Делящееся ядро разваливается на два осколка сравнимой массы с одноврем. испусканием нейтронов и γ -квантов (см. Деление ядер). Протоновая Р. ядер наблюдалась в 1982 С. Хофманом (S. Hofmann) с сотрудниками (см. Протоновая радиоактивность).

В 1984 Х. Роуз (H. Rose) и Г. Джонс (G. Jones) открыли спонтанное искусственное ядро ^{14}C ядрами Ra. В течение последующих 3 лет был обнаружен спонтанный распад др. ядер с вылетом тяжёлых фрагментов (мастеров) — ^{24}Ne и ^{28}Mg (f -радиоактивность). Возможна также двухпротонная Р., теоретически предсказанная В. И. Гольданским (1960).

Число N радиоакт. ядер убывает со временем t по закону

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t),$$

где N_0 — число ядер в момент их образования, λ — постоянная распада (вероятность распада в единицу времени). Если при распаде происходит конкуренция разл. типов (каналов) Р., то λ равна сумме парциальных велич. λ_i . Относит. вероятность наблюдения разл. видов Р. определяется отношением λ_i/λ . Время жизни нестабильного состояния ядра $\tau = 1/\lambda$. Скорость радиоакт. распада характеризуют периодом полураспада $T_{1/2} = \ln 2/\lambda$. Полное время жизни радиоакт. ядра связано с парциальными величинами τ_i соотношением $1/\tau = \sum(1/\tau_i)$. Времена жизни родоначальников радиоакт. рядов $\tau \geq 3 \cdot 10^8$ лет. Это немногие «выжившие» с момента образования Солнечной системы нестабильные нуклиды.

Бета-Р., при к-рой сохраняется массовое число A нуклида, но изменяется на 1 его заряд Z , представляет собой одно из проявлений бета-распада ядер, когда входящий в состав ядра протон p (нейтрон n) превращается в нейтрон (протон) с образованием позитрона β^+ (электрона β^-) и нейтрино ν (антинейтрино $\bar{\nu}$). Аналогичную природу имеет изменение заряда ядра,

связанное с захватом атомарных электронов (электронный захват). Бета-распад связан со слабым взаимодействием нуклонов в ядре.

Остальные типы Р. связаны с сильным взаимодействием и электромагнитным взаимодействием нуклонов в ядрах. Радиоакт. распад, при к-ром испускаются протоны, α -частицы или тяжёлые кластеры ядра ^{14}C , характерен тем, что кинетич. энергия отходит движению вылетающей частицы и дочернего ядра принимает значения, близкие (или равные) к полной энергии распада Q . Поэтому дочернее ядро образуется в основном или слабовозбуждённом состоянии. Времена жизни τ , соответствующие этим типам Р., экспоненциально возрастают при уменьшении кинетич. энергии продуктов распада. Распад имеет квантомеханич. характер, он происходит благодаря туннельному проникновению сквозь потенц. барьер, образованный совокупным действием отталкивательного кулоновского и притягивающего ядерного взаимодействий вылетающей частицы и дочернего ядра (см. Альфа-распад).

Продукты распада формируются внутри и на поверхности родительского ядра, причём вероятность их формирования W зависит от структуры исходного и дочернего ядер. Она резко уменьшается при увеличении массы вылетающей частицы. Отношения вероятностей разл. каналов распада λ_i/λ_j , зависящие от Q_i, Q_j и вероятностей формирования продуктов распада W_i, W_j , сильно варьируются. Напр., отношение вероятностей вылета ядра ^{14}C или α -частицы порядка 10^{-10} — 10^{-11} для различных родительских изотопов Ra. Оно достигает $\sim 10^{-13}$ для распада ядра ^{234}U , когда вместо ^{14}C испускается ^{28}Mg .

Спонтанное деление также оказывается возможным благодаря туннельному проникновению через потенц. барьер. Однако в этом случае барьер связан с изменением формы ядра в процессе деления, что приводит к иным закономерностям, управляющим этим процессом. Для объяснения f -распада рассматривают возбуждение ядра, затрагивающее только часть нуклонов vicinity его поверхности; это колебания формы ядра в осн. состоянии (нулевые колебания). В ядерных реакциях возбуждение таких колебаний приводит к появлению т. н. гигантских резонансов (см. Гигантские квантовые осцилляции). Если в процессе таких колебаний ядро достигает грушевидной формы, то могут образоваться фрагмент и остаточное ядро, удерживаемое нек-рое время, как и при α -распаде. Время жизни ядра относительно f -распада определяется вероятностью W «распадной» конфигурации и прозрачностью барьера. Т. к. W убывает с ростом амплитуды колебаний, то для деформиров. ядер в осн. состоянии (см. Деформированные ядра) вероятность f -распада велика. Действительно, ядра Na имеют квадратную деформацию (эллипсоид) и октаэдрическую (грушевидная форма), к-рые приближают осн. состояние к f -распаду. Прозрачность барьера определяется его высотой, массой фрагментов и гл. обр. энергией распада Q_f . Действительно, в качестве остаточного продукта при f -распаде практически всегда наблюдается ядро Pb с $A = 208$ ($Z = 82, N = 126$); f -распад с образованием такого дважды магического ядра характеризуется большой величиной Q_f .

Получение радиоуклидов в результате ядерных реакций приводит к необходимости измерить мян. время распада, определяемого как радиоактивный, чтобы разделить стадии возникновения радиоуклида и последующего его распада. Это время (10^{-10} — 10^{-12} с) должно превышать время жизни возбуждённого составного ядра в ядерных реакциях.

За работы, связанные с открытием и исследованием Р., присуждено более 40 Ноб. пр. по физике и химии, в т. ч.: А. Беккерелю, П. и М. Кюри, Э. Ферми (Е. Fermi), Э. Резерфорду, И. и Ф. Жолио-Кюри, Д. Хевеши (G. Hevesy), О. Гану (O. Hahn), Э. Макмиллану (E. McMillan) и Г. Сиборгу (G. Seaborg), В. Либби (W. Libby).

Лит.: Кю р и Р., Радиоактивность, пер. с франц., 2 изд., М., 1960; Алфа-, бета- и гамма-спектроскопия, под ред. К. Зигбава, пер. с англ., в. 1—4, М., 1969; Учение о радиоактивности. История и современность, М., 1973; Н о т м а п л с. и др., Протон радиоактивность ^{13}C , ^{12}C , Руби н, 1962; Би А 305, S. 111; Роу е Н. J., Жо не с G. A., A new kind of natural radioactivity, «Nature», 1984, в. 307, p. 245; Ка з а м е н с к и й С. Г., Ф у р м а н В. И., Алфа-распад и родственные ядерные реакции, М., 1985; В. П. Чечев, В. И. Фришман.

РАДИОАКТИВНЫЕ РЯДЫ — см. Радиоактивность.

РАДИОАСТРОНОМИЯ — раздел астрофизики, изучающий радиоизлучение астр. объектов.

Р. зародилась в нач. 30-х гг., когда К. Янски (K. Jansky) исследовал влияние помех на радиотелефонную связь и обнаружил изменение уровня шумов приёмника, коррелирующее с периодом вращения Земли (звёздным временем). Как показали дальнейшие исследования, это было радиоизлучение в центре Галактики. Первая радиостанция была получена Г. Ребером (G. Reber) в 1940. Ставление и дальнейшее развитие Р. связано с послевоен. периодом. Р. существенно расширила возможности астр. исследований, увеличив диапазон регистрируемых частот эл.-магн. излучения.

Радиотелескопы обладают высокой чувствительностью и разрешающей силой (по углу, частоте и времени). Это позволяет получать изображения объектов более высокого качества, чем в оптич. диапазоне, изучать быстротечные процессы в космич. источниках.

Диапазон наземных радиостр. наблюдений (длины волн от неск. миллиметров до ≈ 30 м) определяется прозрачностью атмосферы Земли. КВ-граница диапазона обусловлена поглощением молекул атмосферы, ДВ-граница — отражением и поглощением космич. радиоизлучения в ионосфере. На миллиметровых волнах становится существенным собствен. излучение Земли и атмосферы, а на метровых — космич. (фоновое) радиоизлучение неба, к-рое имеет необычайно высокую яркость и растёт с увеличением длины волны (см. Фоновое космическое излучение). Для снижения влияния фонового радиоизлучения при регистрации сигналов от дискретных космич. радиотелескопов применяются спец. методы приёма сигналов: радиоинтерференционный, диаграммой и частотной модуляции и др. (см. Радиотелескоп).

Непосредственно измеряемая величина в Р. — приращение шумовой температуры T_n антенны радиотелескопа (ΔT_n) при наведении её на исследуемый объект. Исследуемая величина — плотность потока радиоизлучения объекта $F = 2kT_b \lambda^{-2} \Omega$, где Ω — его угл. размер, T_b — яркостная температура, λ — длина волны принимаемого сигнала. Приращение $\Delta T_n = FA_n/2k$, где A_n — эфф. площадь антенны радиотелескопа. Для компактных источников, угл. размеры к-рых меньше диаграммы направленности антенны (Ω_a), $\Delta T_n = T_b \Omega_a/\Omega_n$. Для протяжённых источников ($\Omega > \Omega_a$) $T_n \approx T_b$. Величина F может быть измерена путём определения ΔT_n и A_n (абс. метод) либо по измерениям источника с известной плотностью потока (F_0), $F = F_0 \Delta T_n / (\Delta T_{n0})$ (относ. метод). Точность измерений в Р. определяется полосой регистрац. сигнала Δf , временем его накопления t и шумовой темп-рой системы T_e , $\delta T_n \approx T_e \sqrt{\Delta f t}$ и равна ~ 10 мкВ по темп-ре и неск. мкВ на плотности потока ($1 \text{ Ян} = 10^{-26} \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{Гц}^{-1}$). Угл. разрешение радиотелескопов ($\sim \lambda/D$, где D — размер апертуры) весьма невелико из-за большой длины волны радиоизлучения и, как правило, не превышает разрешения псевдоразрешённого глазом ($\sim 1'$). Для увеличения угл. разрешения используют радиоинтерферометры и системы апертурного синтеза. На основе крупных радиотелескопов создана глобальная радиоинтерференц. сеть (разрешение выше одной мс дуги). Радиоастр. измерения благодаря гетеродинамированию (см. Радиоприёмные устройства) позволяют проводить анализ сигналов на низких (промежуточных) частотах, что обеспечивает универсальность спектроанализаторов и высокое разрешение по частоте, вплоть до 1 Гц (если в этом есть необходимость). Спец. методы обработки на

ЭВМ позволяют анализировать сигналы космич. радиоизлучения, предварительно записанные на магн. ленты, выделять в шумах искомым образом наблюдаемого объекта.

Наблюдаемое радиоизлучение космич. объектов определяется механизмом излучения, условиями генерации и распространения радиоволн, энергией излучающих частиц и магн. поля. Непрерывное излучение космич. источников обусловлено синхротронным и тепловым механизмами (см. Синхротронное излучение, Тепловое излучение). Излучение в узких радиолиниях связано с переходами между уровнями энергии атомов и молекул. В ряде случаев наблюдается мазерное усиление линий (см. Мазерный эффект). Одним из первых объектов исследования радиостр. методами было Солнце. Источником мощного радиоизлучения на метровых волнах является корона Солнца, её яркостная темп-ра $\sim 10^6$ К, а эфф. угл. размер превышает $1'$. Мощное радиоизлучение генерируется в радиопятнах — активных областях. Повышение чувствительности радиотелескопов позволило измерить темп-ры планет. Напр., темп-ра поверхности Венеры оказалась равной ≈ 600 К, что в последующем было подтверждено прямыми измерениями с помощью космич. аппаратов. Предметом исследований является и межпланетная среда, она же — и «инструмент» с высоким угл. разрешением (см. Меридиан. метод). Галактика содержит большое число мощных источников синхротронного радиоизлучения — остатков вспышек сверхновых звёзд, в их оболочках находятся электроны высоких энергий, к-рые излучают в магн. поле. К источникам этого типа относятся, напр., Крабовидная туманность и Гассиоппе А. При взрывах век-рых сверхновых сбрасывается оболочка звезды, а оставшаяся часть сжимается и превращается в нейтронную звезду — пульсар — источник импульсного излучения. В газопыльных комплексах протекают процессы формирования звёзд и планетных систем (см. Звездообразование), сопровождающиеся мощным мазерным излучением в линиях водородного пара ($\lambda = 1,35$ см) и гидроксил ($\lambda = 18$ см). Ионизованный газ и пыль являются источниками теплового радиоизлучения. Межзвёздная среда заполнена реликтивными частицами, к-рые создают фоновое синхротронное излучение, усиливающееся к плоскости Галактики. В межзвёздной среде возникают атомарные и молекулярные спектральные линии (в частности, радиолиния водорода 21 см). Во мн. случаях эти линии связаны с холодным газом и могут наблюдаться только в радиодиапазоне. Др. галактики также являются источниками радиоизлучения, во в связи с их большой удалённостью регистрируется радиоизлучение лишь наиб. мощных из них. Это — квазары, радиогалактики, лентериды (см. Объекты с активными ядрами, Ядра галактик). Вселенная в целом — источник изотропного сантиметрового и миллиметрового радиоизлучения с темп-рой ок. 2,7 К — реликтом ранних стадий её эволюции (см. Микроволновое фоновое излучение).

Лит. см. при ст. Антенна радиотелескопа, Апертурный синтез.

РАДИОАТМОСФЕРА СТАНДАРТНАЯ — условная атмосфера, характеризующаяся набором определ. высотных зависимостей параметров атмосферы, предназначенная для проведения оценочных расчётов разл. характеристик распространения радиоволн. Согласно [1], Р. с. условно определяется как такое состояние атмосферы, при к-ром зависимость ср. значения показателя преломления воздуха n от высоты h над поверхностью Земли $n(h) = 1 + a \exp(-bh)$, где a и b — пост. величины для данного климатич. района. Величина b составляет в ср. 0,136 км $^{-1}$, величина a меняется от $\approx 300 \cdot 10^{-6}$ (у полюсов) до $\approx 400 \cdot 10^{-6}$ (у экватора). Р. с. используется для расчёта эффектов рефракции радиоволн.

Описание Р. с. включает в себя век-рые среднегодовые высотные профили тех атм. параметров, к-рые влия-

ют на распространение радиоволн данного диапазона [2]; высотные зависимости давления, температуры и влажности воздуха. С их помощью можно оценивать поглощение радиоволн сантиметрового и более коротковолновых диапазонов при проектировании систем связи и зондирования Земли из космоса.

Лит.: 1) ССГГ. Пер. 363—2 «Radio-meteorological data», XUIth Plenary Assembly, Dubrovnik, 1966; 2) Standard Atmosphere Supplements, Wash., D. C., 1966. В. Н. Леккер. РАДИОВОЛНЫ (от лат. radio — излучаю) — электромагнитные волны с длиной волны λ от $5 \cdot 10^{-8}$ до 10^8 м (частотой f от $6 \cdot 10^{12}$ Гц до неск. Гц). В опытах Г. Герца (1888) впервые были получены эл.-магн. волны с λ в неск. десятков см. В 1895—99 А. С. Попов впервые применил эл.-магн. колебания с $\lambda \approx 10^2 - 2 \cdot 10^4$ см для осуществления беспроводной связи на расстоянии. По мере развития радиотехники расширился частотный диапазон (табл. 1) радиоволн, к-рые могут генериро-

Табл. 1.

Диапазон	Длина волн в вакууме	Частота колебаний
Сверхдлинные волны (СДВ)	100—10 км	3—30 кГц
Длинные волны (ДВ)	10—1 км	30—300 кГц
Средние волны (СВ)	1000—100 м	300—3000 кГц
Короткие волны (КВ)	100—10 м	3—30 МГц
Ультракороткие волны (УКВ):		
метровые	10—1 м	30—300 МГц
дециметровые	10—1 дм	300—3000 МГц
сантиметровые	10—1 см	3—30 ГГц
миллиметровые	10—1 мм	30—300 ГГц
субмиллиметровые	1—0,05 мм	300—6000 ГГц

Табл. 2.

Номер полосы	Полоса частот*	Название полосы частот	Диапазон длин волн	Название диапазона
1	3—30 Гц	Крайне низкие (КНЧ)	100—10 М	Декамегаметровые
2	30—300 Гц	Сверхдлинные (СНЧ)	10—1 Мм	Мегаметровые
3	0,3—3 кГц	Низкочастотные (НЧЧ)	1000—100 км	Гектокилометровые
4	3—30 кГц	Очень низкие (ОНЧ) (VLF)	100—10 км	Мегаметровые
5	30—300 кГц	Низкие (НЧ) (LF)	10—1 км	Километровые
6	300—3000 кГц	Средние (СЧ) (MF)	1000—100 м	Гектометровые
7	3—30 МГц	Высокие (ВЧ) (HF)	100—10 м	Декаметровые
8	3—300 МГц	Очень высокие (ОВЧ) (VHF)	10—1 м	Метровые
9	300—3000 МГц	Ультравысокие (УВЧ) (UHF)	10—1 дм	Дециметровые
10	3—30 ГГц	Сверхвысокие (СВЧ) (SHF)	10—1 см	Сантиметровые
11	3—300 ГГц	Крайне высокие (КВЧ) (EHF)	10—1 мм	Миллиметровые
12	300—3000 ГГц	Гипервысокие частоты	1—0,1 мм	Децимиллиметровые

* Полосы частот исключают наибольшую и исключают наименьшую частоту, а диапазоны длин волн исключают наименьшую и исключают наибольшую.

ваться, получаться и приниматься радиоаппаратурой (см. Радиопередающие устройства, Радиоприёмные устройства). В природе существуют и естественные источники Р. — во всех частотных диапазонах. Источником Р. является любое горячее тело (тепловые излучение). Источники Р. — звёзды, в т. ч. Солнце, галактики и метagalaktiki. Р. генерируются и при нек-рых процессах, происходящих в земной атмосфере, напр. при разрядке молний (атмосферика), при возбуждении колебаний в ионосферной плазме.

Р. применяются для передачи информации без проводов на разл. расстояния (радиосвязь, радиосвязь, телевидение), для обнаружения и определения положения разл. объектов (радиолокация) и т. п. Р. используются для изучения структуры вещества (см. Радиоспектроскопия) и свойств той среды, в к-рой распространяются; напр., с помощью Р. получены сведения о структуре ионосферы и процессах в ней. Исследование радиоизлучения комет, объектов — предмет радиострономии. В радиометеорологии изучают процессы в атмосфере по характеристикам принимаемых Р. Практич. использование Р. с тем или иными частотами связано с особенностями распространения Р. условиями их генерации и излучения (см. Антенна). В табл. 2 приведено деление Р. на диапазоны, установленное междунар. регламентом радиосвязи.

Лит. см. при ст. Распространение радиоволн. М. Б. Виноградова.

РАДИОГАЛАКТИКИ — галактики, являющиеся источниками мощного радиоизлучения (10^{42} — 10^{44} эрг/с). Термин «Р.» возник в результате отождествления в 50-х гг. 20 в. ряда мощных источников комич. радиоизлучения с относительно слабыми источниками оптич. излучения — далёкими галактиками. Выделение Р. как особого класса галактик в известной степени условно, поскольку установлено, что практически все галактики излучают в радиодиапазоне (правда, с большим различием в мощности излучения — от 10^{37} до 10^{44} эрг/с). С Р. отождествлены десятки тыс. комич. радиосточников.

По особенностям структуры, выявленным на основе наблюдений в оптич. диапазоне, Р. делят дополнительно на неск. типов. Наиб. мощными Р. являются т. н. D-галактики — E-галактики с протяжёнными оптич. оболочками (коронами). Существуют Р. промежуточных типов: Р. типа ДБ занимают промежуточное положение между D-типом и чистым E-типом; Р. типа ДВ обладают свойствами D-галактик, но отличаются ещё тем, что их центр. области выглядят раздвоенными. Это раздвоение в ряде случаев связано с проецированием на центр. область галактики мощного газово-пылевого диска. Наконец, сравнительно редкую группу Р. образуют т. н. N-галактики с ярким звездообразным ядром, обнаруживающим переменность блеска. В скоплениях галактик самые мощные радиосточники всегда отождествляются с их ярчайшими членами — с т. н. D-галактиками.

Эллиптич. E-галактики, как правило, довольно бедны межзвёздным газом. Однако в оптич. спектрах ядер Р. всегда присутствуют интенсивные эмиссионные линии разл. хим. элементов межзвёздной среды. По-видимому, наличие не связанного в звёздах газа в ядрах и окружающих областях E-галактик играет важную роль в энерговыделении, приводящем к образованию Р. Шириня эмиссионных линий (водорода, углерода и др. хим. элементов) свидетельствуют о больших скоростях внутр. движений газа в ядрах — от 300—600 км/с до неск. тысяч и даже десятков тысяч км/с.

У Р. в диапазоне частот от 10 МГц до 10—80 ГГц наблюдается, как правило, степенная зависимость спектральной плотности потока излучения F_ν от частоты ν ($F_\nu \propto \nu^{-\alpha}$; α — спектральный индекс; см. примеры спектров на рис. 1). Радиоизлучение имеет, несомненно, синхротронную природу — излучает релятивистские электроны, движущиеся в магн. полях Р. Важным свидетельством в пользу этого заключения служит наблюдаемая линейная поляризация радиоизлучения (в ср. 8—10%). Степень линейной поляризации возрастает до 40—60% для отд. компактных деталей структуры Р., что близко к предельно возможной степени поляризации (ок. 70%) синхротронного излучения и свидетельствует об определённой (в масштабах до десятков кпк) однородности их крупномасштабных магн. полей. По оценкам, напряжённость магн. поля Р. составляет 10^{-4} — 10^{-8} Э в протяжённых радиоструктурах и 10^{-2} —

10^{-4} Э в компактных околоядерных образованиях (см. *Магнитные поля галактик*).

Карты распределения радиояркости (радиофоты) показывают, что в Р., на правило, имеются два излучающих облака (компонента), располагающихся более или менее симметрично относительно галактики, видимой в оптич. лучах. Обычно излучающие в радиодиапазоне облака находятся в 10—100 кпк от галактики,

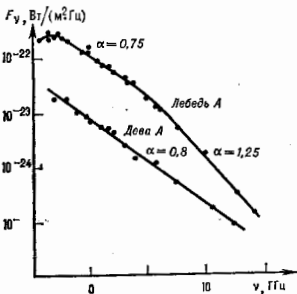


Рис. 1. Спектры радиоизлучения некоторых типичных радиогалактик.

за пределами её звездной составляющей. Известны Р. в n -рых расстоянии между компонентами достигает 2—5 Мпк. На радиоизотопах обычно хорошо видно, что ярчайшими участками радиокомпонентов являются их внеш. края. Компоненты имеют разл. протяженность и объём, и если предположить, что плотности энергии магн. поля и релятивистских частиц в них примерно равны, то заключённая в них энергия может достигать 10^{48} — 10^{50} эрг.

Пока нет общепринятой теории образования характерных для Р. двойных радиоисточников. Из анализа данных наблюдений следует, что радиоисточники образуются в результате выделения энергии в ядре галактики, но не равновозного характера, а более длительного (10^7 — 10^8 лет) и непрерывного, сопровождающегося выбросом струй плазмы с релятивистскими скоростями в двух противоположных направлениях. По-видимому, важную роль при этом играет дипольный характер магн. поля *ядра галактики*, из магн. полюсов α -рога вдоль силовых линий поля вытекают струи релятивистской плазмы. Со временем излучающие и радиодиапазоне облака плазмы расширяются, расстояние между ними увеличивается. О незатухающей активности ядер Р. свидетельствуют обнаруженные вблизи ядер компактные радиоисточники, наиб. контрастно выделяющиеся при наблюдениях в диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн. У нек-рых Р. обнаружены (по синхротронному излучению) крупномасштабные остронаправленные струи выброшенного из ядер вещества, напр. выбросы («джеты») в Р. Дева А (NGC 4486, M87), NGC 6521. Повышенная яркость внеш. краёв компонентов двойной радиоструктуры связана, по-видимому, с явлением динамич. сжатия наружных частей плазменных облаков при движении их от галактик к периферии в результате взаимодействия с сравнительно плотной (10^{-3} — 10^{-4} частиц/см 3) межгалактич. средой.

В качестве конкретного примера Р. рассмотрим Р. Лебедь А — самый мощный внегалактич. источник радиоизлучения, расположенный в созвездии Лебедя. Отдизлучён в 1951 с Е-галактикой (ДВ-радиогалактикой) 16-й звёздной величины. Красное смещение галактики $z = 0,057$ (т. е. расстояние до неё ок. 200

Мпк). Газово-пылевой слой в центре галактики обуславливает характерное радвоеение её оптич. изображения. Оптич. методами обнаружено излучение сильнионизов. плазмы в области ядра галактики; установлено также, что галактика вращается вокруг осн. лежащей в плоскости, перпендикулярной к лучу зрения и направленной вдоль прямой, соединяющей два ярнх компактных компонента радиоизлучения. На рис. 2

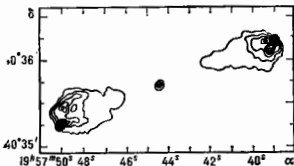


Рис. 2. Радиоизображение (радиофоты) галактики Лебедь А. Зачернены очень яркие области компонентов двойной структуры. Между ними расположено компактный радиоисточник в центре галактики; α — прямое восхождение, δ — склонение.

приведено радиоизображение Р. Лебедь А. Угл. расстояние между яркими областями компонентов двойной структуры ок. 2' (что соответствует прибл. 80 кпк). Верх. предел скорости разлёта компонентов равен 0,02 с. В ядре галактики обнаружен компактный радиоисточник с уплотнённым спектром (с малым значением спектрального индекса). Полная радиосветимость доминирующей в радиоизлучении двойной структуры $3 \cdot 10^{44}$ эрг/с, она сравнима с радиосветимостью двойных структур мн. квазаров. Спектр радиоизлучения (рис. 1) имеет излом, характерный для мн. двойных радиоисточников.

Лит.: Шкловский И. С., Радиогалактики, «УФН», 1952, т. 77, с. 3; В о р о н ц о в В. С. и и н о в В. А., Внегалактическая астрономия, 2 изд., М., 1978; Происхождение и эволюция галактик и звезд, М., 1976, гл. 1; П а х о л а ч и к А. Г., Радиогалактики, пер. с англ., М., 1980.

В. И. Курдюкович,

РАДИОЛОГОГРАФИЯ — метод записи, восстановления и преобразования волнового фронта эл.-магн. волн радиодиапазона, в частности диапазона СВЧ. Методы Р. — прямые аналоги методов оптич. голографии. Голографич. процесс в обоих случаях сводится к получению (регистрации) голограмм и восстановлению (реконструкции) изображения. Для регистрации используются непрерывные среды, чувствительные к излучению радиодиапазона (см. *Регистрирующие голографические среды*), и радиоприёмные устройства. В качестве непрерывных сред применяются плёнки холестерич. жидких кристаллов, тонкие плёнки жидкостей, плёнки автоматоида индия, люминофоры и др. Оптич. свойства этих веществ (цвет, коэффициент преломления, плотность поочернения, интенсивность свечения и др.) зависят от темп-ры и локально изменяются под действием тепла, выделяющегося при поглощении радиоволн. Для регистрации голограмм используются также матрицы газоразрядных диодов, светящихся под действием поля СВЧ. Для реконструкции видимого изображения объекту поверхность материала фотографируют, а затем восстанавливают изображение с помощью полученной оптич. голограммы.

При регистрации голограмм СВЧ с помощью радиоприёмных устройств предметная волна (рассеянная объектом) принимается антенной (зондом) и подается на волнешейный преобразователь (детектор). Опорная волна может существовать в пространстве одномер. с предметной волной, образуя в ней интерференц. картину (естеств. способ), а может имитироваться изменением фазы (искусств. способ) на дискретным в тракте опорной волны (искусств. способ). В Р. используются

одиночные сканирующие антенны и многоэлементные антенные системы (см. *Антенны*).

Р. применяется для моделирования и измерения параметров антенн. Измерение параметров в традиц. радиотехн. методах осуществляется вводом индикаторной антенны в дальнюю зону испытываемой антенны. Для совр. остроуглавленных антенн дальняя зона находится на расстояниях — десятков км, что делает измерения затруднительными, а часто невозможными. Голлографич. методы позволяют определить параметры антенны в зоне Френеля вплоть до полей вблизи антенны. На нек-ром расстоянии от антенны регистрируются радиолограмма и её оптич. модель — транспарант, помещенное к-рой в когерентное световое поле образует распределение, подобное измеряемому. Плоскостное поле преобразуется системой линз так, что в выходе в определ. плоскости образуется распределение поля, соответствующее диаграмме направленности антенны. Обработка результатов измерения поля в раскрыве антенны может производиться на ЭВМ.

Р. используется для исследования удаленных объектов. Небольшая подвижная антенна принимает сигналы от перемещающегося объекта, к-рые записываются в виде радиолограммы. Радиолограмма преобразуется в оптич. модель, реконструкция изображения даёт детальную информацию об объекте. Метод радиологатора с синтезируемой апертурой был использован на «Аполлоне-17» при облёте Луны ($\lambda = 80, 20$ и 2 м); он применяется при исследовании методом голографирования вращающейся планеты, перемещающейся относительно Земли (изображение Венеры в радиоволнах). Р. используется также для получения изображения объектов, скрытых оптич. непрозрачными средами, для определения расположения отражающих участков тропосферы, для обработки сигналов больших антенных решёток и многоэлементных облучателей (космич. связь и навигация), радиосигналов (сжатие радиолокац. импульсов) и др.

Лит.: Бахрах Л. Д., Гаврилов Г. А., Голографич. м. 1978; Радиолография и оптическая обработка информации в микроволновой технике (Сб. ст.), под ред. Л. Д. Бахраха, А. П. Курочкина, М., 1980; см. также лит. при ст. Голографич. РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР — инструмент для измерения с высоким угл. разрешением, состоящий из неск. антенн, расставленных на большое расстояние и связанных между собой ВЧ-линей связи. Простейший Р. (аналог интерферометра Майкельсона) состоит из двух антенн (двухэлементный Р., рис. 1). Сигналы исследуемого радиосточника принимаются антеннами, передаются по ВЧ-кабелю и суммируются (существуют также Р., в к-рых принятые сигналы предварительно детектируются, см. *Интерферометр интенсивности*). Принимаемые антеннами сигналы точечного источника имеют отност. запаздывание τ , к-рое определяется

относит. положением источника θ и длиной базы B , $\tau = B \sin \theta / c$. Отност. запаздывание и, следовательно, разность фаз сигналов изменяются при движении источника по небесной сфере, в результате на выходе Р. возникают интерференц. максимумы и минимумы. Диаграмма направленности одиночной антенны оказывается промодулированной интерференц. лепестками. Ширина интерференц. лепестка $\lambda(B \cos \theta)^{-1}$ соответствует угл. разрешению Р. Чувствительность Р. определяется афф. площадью антенн. Длина базы Р. ограничена ВЧ-линей связи, к-рая обычно не превышает неск. км. На больших длинах баз (до десятков км) используют ретрансляц. линии передач. В радиостроении для повышения чувствительности измерений сигналы принимают в возможно большей полосе частот Δf . Ширину

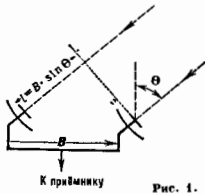


Рис. 1.

и положения интерференц. лепестков на разных частотах различны, что приводит к размытию интерференц. картины. И лишь там, где разность хода лучей равна нулю, интерференц. лепестки совпадают. Кол-во интерференц. лепестков обратно пропорционально ширине полосы, $N = // \Delta f$. Поэтому при наблюдении радиосточников на Р. проводят компенсацию разности хода сигналов.

Дальнейшим развитием Р. является радиоинтерферометр со сверхдлинной базой. Сигналы, принятые антеннами, когерентно преобразуются и записываются на магнитофоны. Когерентное преобразование сигналов проводится с помощью *квантовых стандартных частот*. С их помощью осуществляется и синхронизация записей. Записи считаются с магн. лент спец. процессором, и выделяется коррелиров. сигнал, соответствующий интерференционной картине. В этом случае линии передачи отсутствуют и длины баз могут быть сделаны сколь угодно большими. Для компенсации отност. запаздывания сигналы считаются с соответствующей задержкой. Практически все крупные радиотех. системы мира объединены в единую глобальную радиоинтерференц. сеть. Угл. разрешение сети достигает предельного (в условиях Земли) значения $[10^{-4}$ секунды дуги (на $\lambda \sim 1$ см)].

В отличие от обычного телескопа, Р. регистрирует не изображение объекта $T_b(x, y)$ (T_b — яркостная температура, x, y — угл. координаты на небесной сфере, связанные с источником), а одну из пространственных гармоник этого изображения

$$A(u, v) \sim \iint T_b(x, y) \exp [2\pi i(ux + vy)] dx dy,$$

где u и v — *пространственные частоты*, равные проекциям вектора базы B на оси x и y соответственно, выраженные в длинах волн. Чтобы получить изображение объекта $T_b(x, y)$, необходимо измерить все гармонич. этого изображения, т. е. провести наблюдения объекта на Р. с базами разной длины и ориентации. С помощью обратного преобразования Фурье

$$T_b(x, y) \sim \iint A(u, v) \exp [-2\pi i(ux + vy)] du dv$$

получают (синтезируют) изображение объекта. Практически наблюдения на Р. проводят в пределах всей видимости источника над горизонтом — при разных проекциях базы на радиосточник. Проекция вектора базы описывает на небесной сфере эллипс (рис. 2), к-рый соответствует диапазону пространственных частот данного Р. Далее меняют расстояние между антеннами (Р. с базой перем. длины) и повторяют наблюдения. Для ускорения этого процесса одноврем. используют неск. антенн. Они образуют $n(n-1)/2$ двухэлементных Р. (n — число антенн) и т. о. существенно сокращают время наблюдений. Инструментами этого типа является система апертурного синтеза (VLA) в Нью-Мексико (США), глобальная сеть Р. и др. (см. *Антенны радиотелескопов*).

Радиоинтерференц. метод применяется не только для решения астр. задач, но и в геодезии, космич. навигации, для измерений подвигков земных платформ, движения полюсов Земли и т. д.

Лит. см. при ст. *Антенны радиотелескопов*, *Апертурный синтез*. Л. И. Матвеев.

РАДИОЛИНИЯ ВОДОРОДА 21 см — спектральная линия с длиной волны $\lambda \approx 21,21$ см, обусловленная переходами между подуровнями *сверхтонкой структуры* осн. уровня энергии атома водорода. Причиной сверхтонкого расщепления является взаимодействие спинов

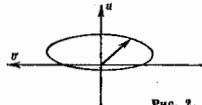


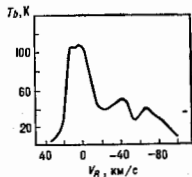
Рис. 2.

ядра и электрона. Энергия атома при параллельном расположении спинов несколько больше, чем при антипараллельном. При изменении ориентации спина электрона на противоположную происходит испускание (или поглощение) кванта излучения с $\lambda \approx 21,1$ см (частота $\nu \approx 1420$ МГц). Принципиальная возможность излучения межзвёздным водородом Р. в 21 см указана в 1945 Х. К. ван де Хюлстом (H. Ch. van de Hulst). В 1948 И. С. Шкловский рассчитал ожидаемую интенсивность радиолинии и показал, что она достаточна для того, чтобы Р. в 21 см можно было обнаружить методами радиоастрономии. В каждом отдельном переходе, рождающий квант радиоизлучения, происходит в ср. 1 раз за 11 млн. лет, но благодаря высокой распространённости атомарного водорода в межзвёздной среде радиолиния оказывается достаточно интенсивной. Р. в 21 см обнаружена в 1951 почти одновременно Х. Юзом (H. Ewen), Э. Перселлом (E. Purcell), К. Мюллером (C. Muller), Я. Оортом (J. Oort).

Р. в 21 см оказалась афф. средством исследования Вселенной. Ок. половины массы галактик, межзвёздного вещества составляет атомарный водород, находящийся в осн. состоянии. Его можно исследовать только по излучению Р. в 21 см; никаким др. образом эта важнейшая составная часть космич. вещества себя не проявляет. Поэтому Р. в 21 см даёт ценные, часто уникальные сведения о строении и распределении материи в космич. пространстве.

Интенсивность Р. в 21 см содержит непосредств. информацию о числе атомов нейтрального водорода на луче зрения (за исключением направлений на некоторые плотные облака, центр и антицентр Галактики, в к-рых межзвёздный газ непрозрачен в этой линии), а частота и профиль линии позволяют определить по эффекту Доплера *лучевые скорости* v_D водорода. В соответствии с моделью дифференц. вращения Галактики эти дан-

Профиль радиолинии $\lambda = 21$ см в направлении области Лебедь X. По оси абсцисс отложена лучевая скорость (v_D), а по оси ординат — яркостная температура линии (T_b).



ные дают возможность определить расстояние до излучающих объектов, т. е. найти распределение нейтрального водорода. Исследования Р. в 21 см позволили установить, что нейтральный водород в Галактике в осн. заключён в очень тонком (≈ 220 пк) и ровном слое около её плоскости. Лишь на периферии на расстояниях, превышающих 10—12 пк от центра Галактики, слой водорода размазывается до 1000 пк по толщине и отклоняется от галактич. плоскости. В распределении водорода довольно отчётливо выделяются спиральные рукава, к-рые прослеживаются до больших расстояний. На рис. приведён профиль Р. в 21 см в направлении области Лебедь X ($\alpha = 20^h 28^m$, $\delta = 42^\circ$). Отчётливо видны максимумы излучения, соответствующие отд. спиральным рукавам. Наиб. интенсивный максимум при $v_D = 3$ км/с соответствует ближайшему к Солнцу т. н. Оронуру рукаву, максимум при $v_D = -40$ км/с — Персееву рукаву. Внутри рукавов нейтральный водород распределён неравномерно, в них выделяются вытнутые вдоль плоскости Галактики комплексы облаков с характерными размерами $\approx 200 \times 50$ пк. Получены данные о зависимости ср. концентрации нейтрального водорода от галактоцентрич. расстояния и о детальном распределении водорода в отд. галактич. областях, в т. ч. в галактическом центре.

Излучение Р. в 21 см наблюдалось также от большого числа др. галактик, что позволило установить отношение массы нейтрального водорода к общей массе галактики в зависимости от её типа. Доля нейтрального водорода увеличивается при переходе от галактик типа Sa к неспiralным, достигая для последних десятков процентов. Мин. кол-во нейтрального водорода наблюдалось у эллиптич. галактик; для подавляющего большинства из них доля нейтрального водорода по массе составляет $\approx 0,1\%$. Для ряда ближайших галактик по Р. в 21 см получены распределения нейтрального водорода в влх и кривые вращения (см. *Вращение галактик*). Ценные данные получены также по красному смещению Р. в 21 см. Линия зарегистрирована более чем от 100 галактик, изменение частоты линии соответствует удалению галактик с разл. скоростями (до $\sim 10^4$ км/с) при хорошей корреляции с красным смещением оптич. линий. Линия водорода, обнаруженная в спектре удалённого внегалактич. источника — квазара 3С 266, оказалась смещённой с частоты 1420,4 МГц до 839,4 МГц, что соответствует красному смещению $z = 0,692$. Полученные данные существенно способствовали развитию теории расширения Вселенной.

Обнаруженная в межзвёздной среде и ставшая афф. средством исследования космич. пространства Р. в 21 см нашла также важное земное применение. На её основе разработаны т. н. активные *квантовые стандарты частоты*. Для создания достаточной интенсивности Р. в 21 см в земных условиях используют вынужденное испускание фотонов атомами водорода. Из источника, в к-ром под влиянием эл. поля разряда при низком давлении происходит диссоциация молекулярного водорода, вылетает пучок атомов водорода. В сортирующем устройстве с помощью магн. поля происходит сортировка атомов: возбуждённые атомы проходят в кварцевую камеру, находящуюся в объёме резонатора, настроенного на частоту линии 21 см, а невозбуждённые — отклоняются в сторону. При достаточной плотности потока атомов, поступающих в камеру, в резонаторе возникает самовозбуждающаяся генерация на частоте Р. в 21 см (подобно ж. с. *Водородный генератор*). Ширина Р. в 21 см в таком водородном генераторе всего 1 Гц. По этой причине квантовый стандарт частоты, работающий на Р. в 21 см, имеет высокую точность. В радиоастрономии этот стандарт как наиб. стабильный используется в качестве эталона в системах радиointерферометрии со сверхдлинными базами.

Льтм. Шкловский И. С. Космическое радиоизлучение, М., 1956; Каплан С. А., Пинкельнер С. Б. Физика межзвёздной среды, М., 1979. Р. Л. Сороченко.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ — раздел астрономии, исследующий тела Солнечной системы с помощью отражённых ими радиоволн, посланных передатчиком с Земли или космич. аппарата (КА). Объекты исследования Р. а. являются *планеты и спутники, кометы, солнечная корона*.

Радиолокация Луны, теоретически обоснованная в СССР в работах Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папанова, впервые осуществлена в 1946 (Венгрия, США). Спустя 15 лет в Великобритании, СССР и США были получены эхо-сигналы от Венеры, к-рая ближе др. больших планет подходит к Земле. Чувствительность радиолокац. установок позволяет исследовать также Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, их спутники, малые планеты (напр., Икар, Эрос) и кометы в периоды их сближения с Землёй. Радиолокац. исследования солнечной короны были начаты в 1959 (США).

В радиолокац. исследованиях небесных тел используются те же физ. принципы, к-рые лежат в основе обычной наземной радиолокации. Интенсивность радиоволн при радиолокации ослабляется обратно пропорционально четвёртой степени расстояния до исследуемого объекта. Из-за огромной величины межпланетных расстояний радиолокаторы, используемые для

исследования небесных тел, имеют антенны больших размеров и мощные передатчики. Напр., радиолок. установка Центра дальней космич. связи в Крыму имеет антенну с диаметром гл. зеркала 70 м и оборудована передатчиками с мощностью непрерывного излучения неск. сотен кВт на волне 39 см и 6 см (см. *Антенна радиотелескопа*).

По сравнению с др. физ. методами исследования небесных тел радиолокация позволяет очень точно измерять расстояние от антенны радиолокатора до исследуемого объекта по запаздыванию отраженных объектов радиоволн. Благодаря этому Р. а. сыграла решающую роль в определении абс. размеров Солнечной системы, уточнил значение астрономической единицы (а. е. — ср. расстояние Земли от Солнца). По этим данным, $1 \text{ а. е.} = 149597870 \pm 2 \text{ км}$.

В то же время анализ радиолокац. измерений показал, что и после внесения поправки в величину а. е. остаются значит. регулярные расхождения между фактическим и афемеридным (вычисленным на основе оптич. наблюдений) положением планет относительно Земли, достигающие неск. сотен км. Для устранения расхождений была создана релятивистская теория движения планет земной группы, учитывающая данные радиолокац. наблюдений планет. Эта теория обеспечивает вычисление взаимных положений планет с погрешностью 1—3 км, что в 100 раз превышает точность прежних расчётов, основанных только на оптич. наблюдениях (СССР, США).

Уточнение взаимных положений планет сделало возможным не только вывод искусств. спутников на орбиту вокруг планет, но и доставку спускаемых аппаратов межпланетных станций в заданный район их поверхности. Высокая точность радиолокац. измерений была использована также для проверки теории тиготы Эйнштейна [4-й проверки общей теории относительности, предложенной И. Шапиро (I. Shapiro)].

При радиолокации непосредственно измеряется расстояние до ближайшей к наземному наблюдателю (антенне радиолокатора) точки поверхности планеты (центра видимого диска планеты), в то время как положение центра масс планеты определяется теорией движения планет, уточненной в процессе самих измерений. Благодаря этому появляется возможность определить радиус планеты в этой точке. Вращение планет (Марса, Меркурия) позволяет исследовать рельеф их поверхности вдоль экватора между тропиками. Профиль высот поверхности Марса, полученный сов. исследователями по наблюдениям 1980, изображен на рис. 1. Трасса измерений прошла по склону гигантско-

го вулкана Олимп (II), где отклонение достигло 17,5 км.

Применение радиолокац. методов (варяду с др. радиоастр. методами) оказалось очень плодотворным в исследованиях Венеры. Поверхность этой планеты закрыта плотной атмосферой, непрозрачной в видимых, УФ- и ИК-лучах. Поэтому оптич. методами не удалось установить период вращения Венеры и выяснить физ. условия на её поверхности. В то же время для радиоволн дециметрового диапазона атмосфера Венеры оказалась прозрачной, что позволило получить достоверные сведения о её поверхности.

Для определения периода и направления вращения Венеры использовано различие лучевых скоростей отд. участков вращающейся поверхности, к-рое приводит благодаря *Доплера эффекту* к уширению спектральной линии отражённых сигналов. Величина этого уширения пропорц. угл. скорости вращения планеты относительно наземного наблюдателя. Это вращение складывается из собств. вращения планеты в инерциальной системе координат и переносного движения системы координат относительно наземного наблюдателя. Результирующее изменение модуля угл. скорости вращения Венеры относительно наземного наблюдателя, вычисленное для неск. значений периода вращения планеты, представлено на рис. 2. На этом же графике нанесены эксперим. точки, полученные по

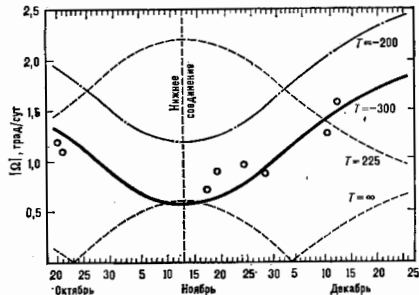


Рис. 2. Определение периода и направления вращения Венеры по наблюдениям вариаций уширения спектра отраженных волн. Кривые представляют изменение модуля угловой скорости Ω видимого вращения Венеры, вычисленное для ряда значений периода T в предположении, что ось вращения планеты перпендикулярна плоскости её орбиты. Экспериментальные точки лучше всего согласуются с кривой, соответствующей орбитальному вращению Венеры с периодом около 300 сут.

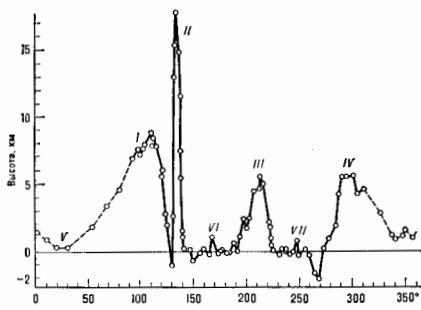


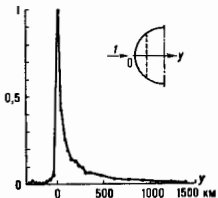
Рис. 1. Профиль высот поверхности Марса вдоль 21° северной широты. Горные массивы: I — Фарсанга, II — Олимп, III — Элизий, IV — Большой Сигт, V — Хриса, VI — Амазонис, VII — Исидра.

наблюдениям уширения спектра отраженных сигналов (СССР, 1962). Наблюдавшееся вращение имеет минимум вблизи вих. соединения, что указывает на обратное вращение планеты. Вариации ширины спектра соответствуют периоду вращения ок. 300 земных суток. Дальнейшее уточнение периода и ориентации оси вращения было проведено по «наблюдению за радиояркими» областями её поверхности. Ось вращения Венеры почти перпендикулярна к плоскости эклиптики. Данные, полученные в СССР и США, указывают на то, что период вращения Венеры несколько меньше значения 243,16 сут. при к-ром Венера в каждом вих. соединении должна быть обращена к Земле одной и той же стороной (г. в. синодич. резонанс).

Для исследования усредненных по поверхности характеристик отражения планет используют как спектральные измерения, так и измерения, построенные на разделении отраженных сигналов по времени их запаздывания. В основе 2-го метода лежит то, что волновой

фронт излучения, падающего по лучу зрения I (рис. 3), постепенно «освещает» всё видимое полушарие планеты, начиная от ближайшей к наземному наблюдателю точки O , и отражённое излучение западает в соответствии с расстоянием данного участка поверхности.

Рис. 3. Распределение энергии отражённых Венерой волн (вертикальная ось) по лучу зрения (горизонтальная ось y), постепенно «освещает» всё видимое полушарие планеты, начиная от ближайшей к наземному наблюдателю точки O , и отражённое излучение западает в соответствии с расстоянием данного участка поверхности.



Распределение энергии отражённого Венерой излучения, полученное этим методом в 1962, представлено на рис. 3. Резкий максимум в точке, соответствующей центру диска планеты, говорит о наличии зеркального блика, присущего гладким поверхностям (заметим, что в оптич. диапазоне поверхности планет рассеивают диффузно). Величина коэф. отражения поверхности (0,12—0,18) такая же, как и у земных скальных пород на силикатной основе. Т. о., была установлена природа отражающей поверхности Венеры, подтверждённая прямыми измерениями со спускаемых аппаратов.

Хотя радиолокационные антенны не обладают той разрешающей способностью, какую имеют оптич. телескопы, разделение отражённых сигналов одноврем. по запа-

даванию и частоте позволяет получать изображение поверхности планеты. С помощью крупнейших радиолокац. установок (Аресибо и Голдстон, США) получены изображения отд. участков обращённого к Земле в период сближения полушария Венеры с пространственным разрешением 10—20 км и несколько выше.

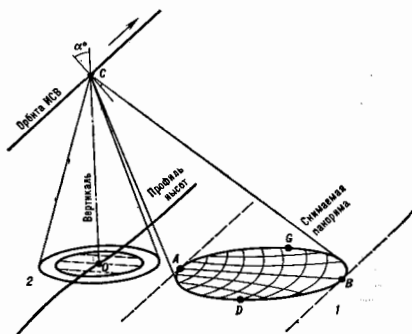


Рис. 4. Схема радиолокационной съёмки с космического аппарата: 1 — линии равных западаваний (концентрические окружности с центром под спутником) и равных доплеровских смещений (гиперболы) в диаграмме направленности антенн бонового обзора; 2 — след диаграммы направленности антенны радиовысотомера.

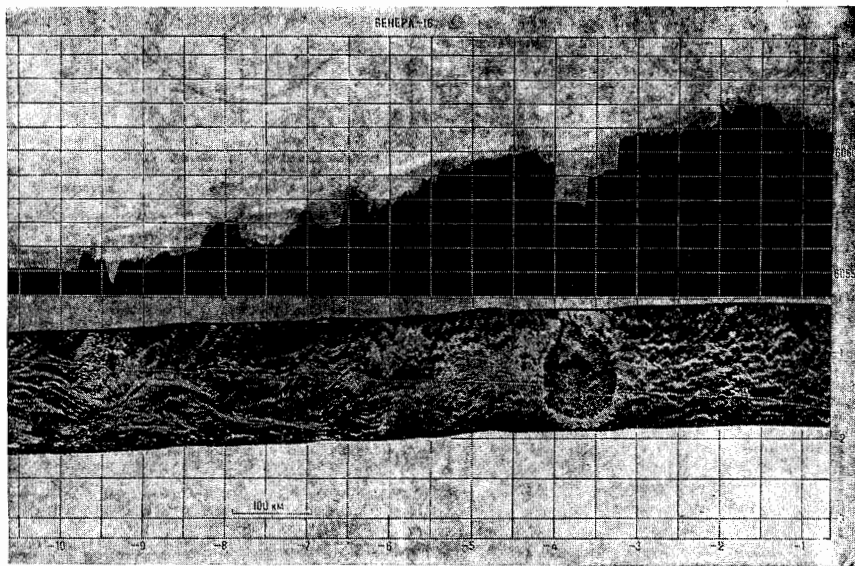


Рис. 5. Радиолокационное изображение района гор Максвелла на Венере, полученное космическими аппаратами «Венера-15», «Венера-16». Вверху приведен высотный профиль поверхности по трассе, отмеченной белой линией (отсчёт высоты ведётся от центра планеты). Изображённый фрагмент поверхности имеет длину 1100 км, ширину 150 км.



Рис. 6. Фрагмент карты гор Максвелла с кратером Клеопатры. Карта составлена из отдельных полос ежедневной съемки поверхности Венеры с космического аппарата.

В 1980 с помощью радиовысотомера, установленного на космич. аппарате «Пионер-Венера» (США), проведена съемка поверхности Венеры с разрешением ≈ 100 км. В 1983—84 радиолокац. съемку всего сев. полушария Венеры выше 30° выполнили сов. космич. аппараты «Венера-15» и «Венера-16». Радиолокац. станция бокового обзора с синтезом апертуры (см. *Апертурный синтез*) на искусств. спутнике Венеры обеспечила пространственное разрешение 1—2 км (при съемке с высот 1000—2000 км).

С помощью передатчика и антенны, установленных на спутнике, радиоволнами освещается нек-рый участок *ADBC* поверхности сбоку от трассы полета (рис. 4). Элементы поверхности в пределах диаграммы направленности антенны находятся на разном расстоянии и движутся с разными радиальными скоростями при наблюдении их со спутника. Напр., точка *A* находится ближе, чем точка *B*, и отраженные ею сигналы будут приняты раньше. С др. стороны, точка *C* приближается к аппарату и отраженные ею сигналы вследствие эффекта Доплера будут выше по частоте, чем сигналы, отраженные точкой *D*, к-рая удаляется. Это и используется для разделения радиоволн, отраженных отд. элементами поверхности, и построения изображения.

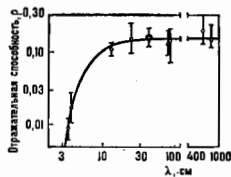
На рис. 5 (внизу) изображен район гор Максвелла на Венере с кратером Клеопатры радиам. ок. 100 км. Яркость видимых образований определяется в первую очередь углом, под к-рым их элементы встречают падающие на них радиоволны. Склоны горных образований, обращенные к космич. аппарату, выглядят светлыми, противоположные склоны — темными. Расшиф-

ровать видимые на снимках образования помогают измерения радиовысотомера. Он непосредственно измерял высоту космич. аппарата над ср. поверхностью планеты в пятне диам. 40—50 км (рис. 4). Благодаря спец. методике, учитывающей разброс высот и шероховатость поверхности в пятне, среднеквадратичная погрешность измерения высот не превышала 30 м. Трасса измерений высоты на рис. 5 показана белой линией. Кратер, к-рый пересекала трасса измерений высоты, расположен на склоне горного массива и имеет сложную форму. Из сопоставления изображения с профилем следует, что внутри большого кратера глубиной ок. 1,5 км находится второй, дно к-рого опущено ещё на 1 км.

Все радиолокационные изображения, полученные в результате систематич. съемки, продолжавшейся в течение 8 мес, были объединены, что позволило создать детальные карты, вошедшие в первый «Атлас поверхности Венеры». Фрагмент одной из карт приведен на рис. 6. В 1990 радиолокац. съемка Венеры продолжена космич. аппаратом «Магеллан» (США). К 1992 осуществлена съемка практически всей поверхности планеты при более высоком разрешении.

Атмосфера Венеры (а также плотные атмосферы Юпитера, Сатурна) оказывают влияние на распространение радиоволн, что используется для исследования физ. свойств атмосферы. С атом. поглощением связано, напр., резкое уменьшение отражат. способностей Венеры на сантиметровых волнах (рис. 7). Причиной этого является резонансное поглощение аз.-магн. излучения в углекислом газе (из к-рого почти целиком состоит её атмосфера) и парах воды, возникающее в условиях высокого давления (до 100 атм у поверхности Венеры).

Рис. 7. Зависимость отражательной способности ρ Венеры от длины волны λ . Резкое увеличение в сантиметровом диапазоне вызвано поглощением электромагнитного излучения в атмосфере Венеры.



При радиолокации Юпитера отражённый сигнал не зарегистрирован. По-видимому, радиоволны практически полностью затухают в очень глубокой атмосфере Юпитера. Аналогично радиоволны должны затухать в атмосферах и др. планет-гигантов. В то же время кольца Сатурна оказались хорошим отражателем и рассеивают радиоволны подобно туму, как облака рассеивают видимый свет.

Если при радиолокации Луны, Венеры, Марса радиоволны отражаются от твёрдой поверхности, то при исследовании Солнца отражения приходят от ионизованного разреженного газа, образующего солнечную корону. Для исследования Солнца используют волны метрового диапазона. Более короткие волны проникают глубоко и затухают, прежде чем отразятся от к-л. образований. Плазма солнечной короны не имеет резкой границы. В ней обнаружены неоднородности, движущиеся со скоростями до 200 км/с. Радиолокация позволяет исследовать динамику солнечной короны.

Лит.: Котельников В. А. и др., Развитие радиолокационных исследований планет в Советском Союзе, в кн.: Проблемы современной радиотехники и электроники, М., 1980; Кисилев М. Д. и др., Великая релятивистская теория движения внутренних планет Солнечной системы, «ДАН СССР», 1980, т. 255, № 3, с. 545; Александров Ю. Н. и др., Вновь открытая планета. (Радиолокационные исследования Венеры с космическим аппаратом «Венера-15» и «Венера-16»), в кн.: Итоги науки и техники. Сер. Астрономия, т. 32, М., 1987; Атлас поверхности Венеры, М., 1989. О. Н. Рашина.

РАДИОЛОКАЦИЯ — обнаружение и определение местоположения разл. объектов с помощью радиотехн. устройств. Первые радиолокац. станции (РЛС), называемые также радиолокаторами или радарам, появились в Великобритании, СССР и США в кон. 1930-х гг.

Принцип действия систем радиолокации состоит в обнаружении и регистрации вторичных радиоволн, отражённых (рассеянных) наблюдаемыми объектами (см. *Отражение радиоволн*, *Рассеяние радиоволн*) при облучении их эл.-магн. волнами радиолокац. передатчика. Приём вторичных радиоволн направленной антенной позволяет определять угл. положение объектов относительно радиолокатора, а измерение времени запаздывания отражённых сигналов по отношению к сигналам передатчика — удаление объектов от радиолокатора. Ур-ние Р. для мощности P_r принятого сигнала

$$P_r = \frac{P_t G_t}{4\pi R^2} \frac{\sigma}{4\pi R^2} A_r,$$

где P_t — излучаемая мощность, G_t — усиление антенны на передачу, σ — эфф. площадь рассеяния (ЭПР) объекта, A_r — эфф. площадь поглощения приёмной антенны, R — дальность объекта Р.

Основные методы радиолокации. Наибольшее распространение получила активная импульсная Р. Вследствие того, что излучение зондирующего импульса заканчивается раньше прихода отражённого сигнала, для передачи и приёма в импульсных РЛС служат одна и та же антенна. Укрупнённая блок-схема РЛС изображена на рис. 1. Широкое применение в передающих устройствах РЛС нашли магнетроны, однако в большинстве современных РЛС передатчик построен по схеме *усилителя электрических колебаний* (с выходным каскадом на *клетроне* или *лазе безлучевой волны*) и имеет задающий ВЧ-генератор, служащий

также источником гетеродинного напряжения приёмника (см. также *Радиоприёмные устройства*), а процессор сигнала представляет собой цифровое устройство, на к-рое принятые сигналы поступают после аналого-цифрового преобразователя. Устройство отображения выполняется обычно на *приёмных электронно-лучевых трубках* и даёт наглядную координатную и допл. инф-цию о наблюдаемых объектах, контролируемых зонах пространства с имеющихся помех (напр., гидрометеорох). Направление на объект Р. в РЛС с механически управляемой антенной определяют по углу наклому её положения, при к-ром величина принимаемого сигнала достигает максимума; в РЛС с электронно управляемым лучом вместо угл. положения антенны измеряют угл. положение луча относительно нормали к раскрыву антенны.



Рис. 1.

Макс. дальность R_{\max} обнаружения может быть выражена через энергию зондирующего сигнала E_t , для к-рого приёмник представляет собой согласованный фильтр:

$$R_{\max}^4 = \frac{E_t G_t A_r}{(4\pi)^2 E_{\text{ш}} \eta},$$

где $E_{\text{ш}}$ — энергия шума в приёмной системе, ρ — отношение сигнала к шуму, обеспечивающее обнаружение с заданной вероятностью при заданном уровне ложных тревог, $\eta < 1$ — коэфф. потерь полезной энергии. Вероятность обнаружения D и вероятность ложных тревог $F_{\text{л.т.}}$ — связанные параметры. Простейший вид эта связь имеет для обнаружения по одному импульсу сигнала с равесным распределением амплитуды:

$$\ln D = \frac{\ln F_{\text{л.т.}}}{\rho + 1}.$$

Требуемая энергия зондирования может быть сосредоточена в одном импульсе или в группе из n когерентных импульсов (т. е. импульсных «выразов» из одного синусоидального колебания; при этом напряжение сигнала на выходе возрастает в n раз в сравнении с одним импульсом). Возможно также увеличить энергию сигнала за счёт некогерентного интегрирования импульсов на видеочастоте; в этом случае не требуется поддержания определённых фазовых соотношений между импульсами на высокой и промежуточной частотах, но напряжение на интеграторе будет возрастать только как \sqrt{n} . В теории Р. доказывается, что существует оптимальный приём, при к-ром достигается наибольшее возможное при данной энергетике превышение сигнала над шумом на выходе «согласованного фильтра» (*фильтра электрического*, импульсная характеристика к-рого является «зеркальным отражением» на ось времени). Когерентный приём позволяет приблизить энергетку РЛС к теоретич. пределу.

При когерентном приёме может существенно проявляться отличие несущей частоты отражённого под-

визным объектом сигнала от частоты облучающего сигнала. Эта разность, называемая доплеровским сдвигом частоты, $f_d = 2v_r/\lambda$, где v_r — радиальная скорость объекта, λ — длина волны (см. *Доплера эффект*). При длительности пачки t_k когерентно накапливаемых импульсов полоса частот пачки и полоса доплеровского фильтра равны $\Delta f_k = 1/t_k$. При $f_d > \Delta f_k$ возможно выделить сигналы подвижных объектов на фоне неподвижных предметов или земной поверхности, находящиеся на той же дальности. РЛС, использующие данный эффект, наз. импульсно-доплеровскими. В Р. применяются и др. способ выделения сигналов подвижных объектов на фоне мешающих отражений — селекция движущихся целей, основанная на чередованном вычитании последовательно принимаемых сигналов на промежуточной частоте.

По характеру функционирования радиолокаторы разделяются на 2 осн. класса: РЛС обзора и РЛС сопровождения. РЛС обзора периодически зондируют все угл. направления сектора ответственности, обнаруживают движущиеся объекты и прокладывают траектории их движения в проекции на земную поверхность (двухкоординатные РЛС) или в пространстве (трёхкоординатные РЛС). Период осмотра пространственного сектора пропорционален ср. мощности зондирующих сигналов РЛС. РЛС сопровождения в течение всего рабочего цикла измеряет координаты движущихся относительно РЛС объектов. Многофункциональные РЛС совмещают обзор и сопровождение. В полной мере многофункциональность реализуется в РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР), обеспечивающей практически безынерционное перемещение антенного луча в угл. секторе, достигаемом для плоской ФАР 120° (рис. 2; по горизонтали — время, по вертикали — угл. положение антенного луча по азимуту; вытянутые по оси времени прямоугольники отображают процесс обзора; горизонтальный размер малых прямоугольничков — время обслуживания одного угл. направления, на протяжении к-рого обзор пространства прерывается). На каждом азимуте луч шириной θ задерживается на время t_e зондирования сектора ответственности на углу места (на рис. не показан), после чего цикл повторяется на смежном азимуте. Наряду с обзором ведётся сопровождение объектов на азимутах β_1 и β_2 .

Основные параметры РЛС. Разрешающая способность и точность определения координат являются коррелиров. характеристиками РЛС. Разрешающая способность по угл. координате приблизительно равна ширине θ антенного луча, а среднеквадратичное значение случайной шумовой ошибки сопровождения

$$\sigma_\theta = \theta / \sqrt{2\rho h},$$

где ρ — отношение сигнала к шуму по мощности, h — число эффективно интегрируемых выборок для системы сопровождения. Помимо шумовой ошибки имеются др. случайные ошибки, так что как бы велик ни был сигнал, угл. ошибка не стремится к нулю. Из наиб. распространенных способов измерения угл. координат (на проходке, путём конич. сканирования, переключенным диаграммы, моноимпульсным методом — см. рис. 3) наиб. точность даёт последний метод. В сантиметровом диапазоне достигнута минимальная суммарная ошибка измерения угла порядка $0,01 \theta$. Разрешающая способность РЛС по дальности $\Delta R = c/2\Delta f_c$, где Δf_c — ширина спектра зондирующего сигнала. Среднеквадратичное значение случайной шумовой ошибки измерения дальности при сопровождении

$$\sigma_R = \Delta R / \sqrt{2\rho h}.$$

Для увеличения дальности действия РЛС необходимо повышать энергию зондирования, что достигается либо увеличением мощности в импульсе, либо уве-



Рис. 2.

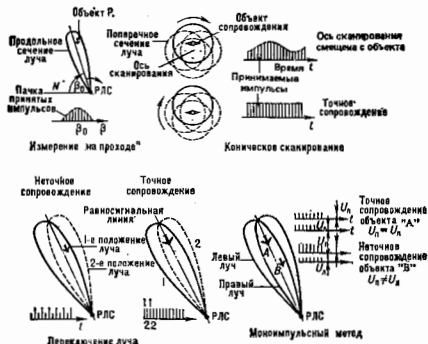
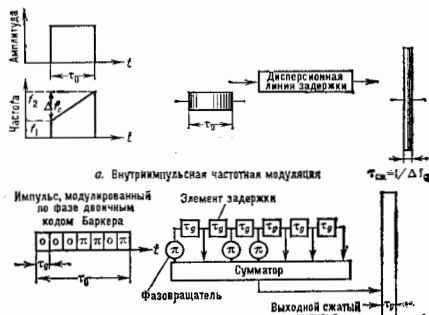


Рис. 3.



Б. Внутримпульсная фазо-кодовая модуляция

Рис. 4.

личением его длительности. Второй путь предпочтительнее, т. к. устраняет ряд инженерных проблем, связанных с более высокими электрич. напряжениями. Но для сохранения при более длит. импульсах заданного разрешения по дальности требуется внутримпульсная частотная модуляция (ЧМ) или фазо-кодвая модуляция (ФКМ), обеспечивающая ширину спектра Δf_c зондирующих сигналов, равную $c/\Delta R$, где c — скорость света. От длительности зондирующего импульса разрешения не зависит, но при обоих видах модуляции от неё зависит уровень мешающих боковых лепестков и ширина области их существования.

В случае внутримпульсной линейной ЧМ принимаемый отражённый сигнал после преобразования на промежуточную частоту (см. *Преобразование частоты*) поступает на частотно-дисперсионную линию задержки (рис. 4, а), на выходе к-рой появляется сжатый импульс длительности $1/\Delta f_c$. При внутримпульсной ФКМ принимаемый отражённый сигнал после преобразования на промежуточную частоту поступает на линию задержки с отводами (рис. 4, б), отображающими кодовую последовательность ФКМ зондирующего импульса и снабжённую такими фазосдвигающими элементами в отводах, к-рые обеспечивают синфазное суммирование всех парциальных сигналов при достижении импульсом конца линии задержки; при этом на сумматоре появляется сжатый импульс длительностью $1/f_c$.

Применение линий задержки, сумматоров, частотных фильтров, временных селекторов в виде аналоговых устройств сопряжено с рядом неудобств, обусловленных их нестабильностью, необходимостью регулировки, сложностью и высокой стоимостью. Поэтому в совр. РЛС широко применяется цифровая обработка принимаемых сигналов. Для цифровой обработки принятый сигнал после преобразования частоты и усиления подаётся на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), на выходе к-рого получаются выборки сигнала в виде двоичного цифрового кода, несущие в себе информацию как об амплитуде, так и о фазе принятого сигнала. Далее все операции производятся с помощью цифровых фильтров, интеграторов и устройств для селекции движущихся целей. Широкое применение в цифровых процессорах сигнала находит быстрое *Фурье преобразование*, резко снижающее требования к объёму вычислений и позволяющее осуществить многоканальную фильтрацию в частотной области. Важнейшее значение имеют характеристики АЦП: его разрядность определяет динамич. диапазон приёмника РЛС, его быстродействие — достижимое разрешение по дальности. Совр. АЦП обеспечивают быстродействие 20 МГц при 12 разрядах.

В наземных и корабельных РЛС используются габр. дециметровые и сантиметровые волны. В самолётных РЛС, где габариты антенн строго ограничены, применяются только короткие сантиметровые волны. Имеются также РЛС на волнах 8 м и даже 3 мм. Ограничение длины волны снизу определяется резко возрастающими с уменьшением λ потерями в атмосфере.

Кроме активных радиолокаторов, работающих по отражённому сигналу, существуют пассивные радиолокаторы, использующие естеств. излучение объектов (радиометры). Такие устройства могут непосредственно измерять только угл. координаты.

Лит.: Современная радиолокация, пер. с англ., М., 1969; Справочник по радиолокации, под ред. М. Скоинина, пер. с англ., т. 1—4, М., 1976—78; Кук Ч., Бернфельд И. М., Радиолокационные сигналы, пер. с англ., М., 1971; Теоретические основы радиолокации, под ред. Я. Д. Ширмана, М., 1970; Леонов А. И., Фомичев К. И., Моноимпульсная радиолокация, 2 изд., М., 1984.

РАДИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, возбуждаемая ядерными излучениями (α -частицами, электронами, протонами, нейтронами, γ -излучением), а также жёстким рентг. излучением.

РАДИОМЕТР (от лат. radio — излучаю и греч. μέτρον — измеряю) — 1) прибор для измерения энергии эл.-магн. излучения, основанный на его тепловом действии (см. *Вольтметр*). 2) Приёмное устройство ра-

диолокатора. источников (см. *Радиотермия*). 4) Прибор для измерения дальности звукового излучения (см. *Радиометр акустический*).

РАДИОМЕТР АКУСТИЧЕСКИЙ — прибор для измерения давления звукового излучения и, следовательно, плотности энергии звуковой волны, интенсивности звука и др. параметров волны. Посредством Р. а. измеряют обусловленную *дальностью звукового излучения* радиационную силу F_p , действующую на помещённое в звуковое поле препятствие (приёмный элемент).

Приёмный элемент Р. а. обычно выполнен в виде лёгкого диска, шарика или конуса, размер к-рых d , как правило, много больше длины УЗ-волны λ . Радиационная сила смещает приёмный элемент из положения равновесия. При определ. отклонения действие её уравновешивается силами, зависящими от конструкции Р. а.: в Р. а. маятникового типа (рис., а) — это компонента силы тяжести, возникающая при отклонении подвеса



на определ. угол; в Р. а. типа крутильных весов (рис., б) — это упругий момент закручивания нити; в ряде конструкций Р. а. упругая сила создается пластичной или спиральной пружиной, изгибом тонкого стеклянного волокна и т. п. В наб. точных компенсационных Р. а. внеш. сила возвращает приёмный элемент в исходное положение равновесия. Простейший тип такого Р. а. — чувствительные рычажные весы (рис., в), где действие силы F_p на одну из чашек компенсируется сжатием разновесов с др. чашки. Более точны эл.-динамич. или эл.-магн. системы компенсаций, применяемые для разл. конструкций Р. а.

В Р. а. без компенсации малые смещения приёмного элемента определяются с помощью микроскопа, а малые повороты — по отклонению светового луча, отражающегося от зеркала на подвижной системе Р. а.

При определении ср. плотности звуковой энергии E и интенсивности УЗ / необходимо принимать во внимание зависимость силы F_p от ориентации приёмного элемента, от его формы и коэф. отражения звука по амплитуде R , а также от соотношения d и λ . В приёмном элементе в виде диска $d \gg \lambda$

$$F_p = ES(1+R^2) \cos^2 \theta = c^{-1} S(1+R^2) \cos^2 \theta,$$

где c — скорость звука, S — площадь диска или площадь поперечного сечения УЗ-пучка (меньшая из площадей), θ — угол между направлением распространения волны и нормалью к диску. При несоблюдении условия $d \gg \lambda$ вводится дифракц. поправка.

Метод Р. а. является одним из наб. простых методов абс. измерения интенсивности УЗ в области средних и высоких частот. Однако Р. а. иверсионен и подвержен

влиянию акустических течений, что снижает точность измерений. Мин. интенсивности, измеряемая с помощью чувствительных Р. а., лежит в области 10^{-4} — 10^{-6} Вт/см².

Лит.: Матаушек И., Ультразвуковая техника, пер. с нем., М., 1962; Колесников А. Е., Ультразвуковые измерения, 2 изд., М., 1982.

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — возникновение силы отталкивания между двумя поверхностями, поддерживаемыми при разных темп-рах T_1 и T_2 ($T_1 > T_2$) в помещаемых в разреженный газ. Отталкивание объясняется тем, что молекулы газа, ударившись о 1-ю поверхность, отскакивают с более высокой кинетич. энергией, чем молекулы, провазимодействовавшие со 2-ой поверхностью. В результате поверхность холодной пластины, обращённая к горячей, бомбардируется частицами, имеющими в ср. больший импульс, чем др. её сторона. Благодаря разнице импульсов, передаваемых при ударе молекул противоположным стенкам пластины, возникает сила отталкивания. При достаточном разрежении газа, т.е. когда длина свободного пробега молекул превышает расстояние между пластинами, сила отталкивания, приходящаяся на единицу площади пластины, равна

$$F = \frac{1}{2} p \left(\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} - 1 \right),$$

где p — давление газа. При более высоком давлении газа «горячие» молекулы теряют часть энергии при столкновениях с «холодными» молекулами. В общем случае

$$F = \frac{1}{c} \left(\frac{p}{a} - \frac{p}{b} \right),$$

где a , b и c — эмпирич. коэффициенты.

На Р. э. основано действие радиометра Крукса (вертушки Крукса) и радиометрич. манометра.

РАДИОМЕТРИЯ — совокупность методов измерений активности (числа распадов в единицу времени) радиоизотопов, содержащихся в радиоакт. источниках. Родоначальники — Э. Резерфорд (E. Rutherford) и Х. Гейгер (H. Geiger), впервые в 1903 измерившие число α -частиц, испускаемых в 1 с 1 г Ra (з.д. активности). В 1899 Ю. Эльстер (J. Elster) и В. Г. Гайтлер (W. H. Heitler) установили экспоненциальное убывание со временем числа атомов чистого радионуклида.

Активность. Осн. закон радиоакт. распада имеет вид:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N = -\ln 2 N / T_{1/2}, \quad (1)$$

где N — число атомов радионуклида, λ — постоянная распада, $T_{1/2}$ — период полураспада (см. Радиоактивность). Кол-во атомов, оставшееся спустя промежуток времени t , определяется соотношением

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t). \quad (2)$$

Постоянная распада λ практически не зависит от таких внем. факторов, как давление, темп-ра и т. д.; в нек-рых случаях наблюдается слабая зависимость от хм. окружения, напр. для ^{90m}Nb в металле по сравнению с ^{90m}Nb во фторидном комплексе изменение λ достигает почти 4% (индекс «м» означает изомерное состояние, см. Изомерия ядерная). Активность A радионуклида определяется выражением

$$A = \lambda N, \quad (3)$$

где λ выражена в с.

Единицей активности в системе СИ является Беккерель (Бк), равный 1 распаду в 1 с. Исторически первая единица активности Кюри (Ки) была установлена как активность газа Rn, находящегося в равновесии с 1 г Ra. В 1950 она была принята равной $3,7 \cdot 10^{10}$ распадов в 1 с. Активность, отнесённую к массе образца, вва. массовой, к объёму — объёмной.

Для характеристики содержания активности T в объектах внем. среды используют т. н. триединую единицу ТЕ, она соответствует концентрации T , при к-рой один его атом приходится на 10^{18} атомов водорода. В 1963 Национальное бюро стандартов США рекомендовало заменить термин «триединая единица» термином «триединое отношение» (ТО): $1 \text{ TO} = 1 \text{ TE} = 6,866 \cdot 10^7$ ат. Т · кг⁻¹ = $3,193 \cdot 10^{-12}$ Ки · кг⁻¹ = $0,4181$ Бк · кг⁻¹ [атомная единица (АЕ) была принята для отношения активности ¹³⁷Cs к массе К в организме, продуктах питания и т. д.; 1 АЕ = 37 Бк · кг⁻¹ или 1 Ки · г⁻¹].

Активность A находят, измеряя интенсивность излучений, сопровождающих распад, или определяя кол-во радиоакт. атомов в источнике. Напр., активность ⁹⁰Tc в виде кусочка чистого металла определяют взвешиванием; активность ¹Bk соответствует числу атомов Tc, равное $1,443 T_{1/2}$; активности 1 Ки соответствует $3,6 \cdot 10^{18}$ атомов Tc и масса 59 г.

Измерения активности подразделяют на абс. и относительные (сравнение воздействия радионуклида, содержащегося в источнике, с аналогичным воздействием от эталонированного источника). Методы измерений различают по способу приготовления источника, геометрии измерений, виду излучения, типу детектора, используемому фп. эффекту, способам обработки информации, уровням измеряемых активностей.

По способу приготовления образца выделяют методы «бесконечно тонкого» и «бесконечно толстого» слоёв, метод количеств. перевода радиоакт. «метки» в определ. хм. формы для получения удобных для измерения жидкостей и газов и др. Метод «бесконечно тонкого» слоя основан на приготовлении источника с пренебрежимо малым поглощением излучения радионуклида в самом источнике. В случае «бесконечно толстого» слоя толщина радиоакт. слоя в источнике больше макс. проба испускаемых частиц.

По геометрии измерений выделяют т. н. 4л-геометрию, промежуточную и измерения в малом телесном угле. В 4л-геометрии детектор окружает источник со всех сторон. Это осуществляется при помощи газоразрядных т. н. 4л-счётчиков или наполнением счётчика активным газом. Близкая к 4л геометрия осуществляется в жидкостных *цинтилляционных детекторах*, *ионизационных камерах*, *полупроводниковых* и др. детекторах с каналами («коллодиями») для размещения источников. В случае низкой массовой активности источники размещают непосредственно на детекторе. Для снижения минимально детектируемой массовой активности детектор окружают контейнером с препаратом (Маринелли, 1950).

По используемому эффекту методы измерения активности подразделяются на ионизационные, газоразрядные, цинтилляционные, калориметрич., масс-спектрометрич., фотометрич. и др. Название приборов содержит указание на метод измерения, геометрию и вид излучения, напр. 4л-Х-счётчик высокого давления (Х — рентген), *полупроводниковый детектор* Ge(Li), *цинтилляционный детектор* NaI(Tl) и т. д.

По способам обработки информации от детекторов выделяют метод интегрального счёта, *совпадения метод*, *позиционно-чувствит. метод* и др. Интегральные методы применяют при измерении активности чистых радионуклидов или при отнесит. измерениях с помощью стандартных образцов. Спектрометрич. методы регистрируют как интенсивность излучения, так и его спектр; они позволяют селективно измерять активность отд. радионуклидов в их смесях. Методы совпадений и антисовпадений используют как для повышения селективности измерений радионуклидов, обладающих каскадным излучением, так и для абс. измерений. Если распад сопровождается каскадным испусканием двух излучений разного рода или разных энергий, в установку включают два детектора, настроенных на раздельную регистрацию этих излучений. При этом актив-

ность радионуклида находят с помощью выражения:

$$A = \frac{n_1 n_2}{n_{12}} B \left(\frac{n_1}{n_{12}} \right), \quad (4)$$

где n_1 , n_2 — скорости счёта от каждого детектора, n_{12} — скорость совпадений, ф-ция $B(n_1/n_{12}) \rightarrow 1$ при $(n_1/n_{12}) \rightarrow 1$.

Позиционно-чувствительные системы применяют при хроматографической, аналитической радиоактивных препаратов. Установки, включающие ЭВМ, со спец. детекторами позволяют находить распределение источников излучения на разных сечениях исследуемого объема (а м с и о н а я т о м о г р а ф и я). Такие установки дают возможность изучать распределение в организме веществ, меченых γ -излучающими радионуклидами (гамма-камеры).

Эффективность регистрации γ -излучения. Отношение общего числа импульсов, поступающих от детектора (независимо от энергии, потерянной в его чувствительном объёме) к числу попаданий в детектор наз. *полной* с ϵ *чётной* эффективностью ϵ_c . При работе с *гамма-спектрометрами* наиб. часто определяют суммарный импульсов в пике полного поглощения. Т. к. осн. часть импульсов в пике полного поглощения обычно связана с фотоэффектом, то говорят об *фотоэффективности* (см. *Гамма-излучение*).

Для сравнения детекторов используют относительную эффективность — отношение эффективности регистрации данного детектора и сцинтиляционного детектора NaI(Tl) diam. и высотой 76,2 мм в пике полного поглощения при энергии γ -излучения $\epsilon_\gamma = 1332$ кэВ (источник — ^{60}Co) или 661,7 кэВ (^{137}Cs). Напр., для полупроводникового детектора Ge(Li) с чувствит. объёмом 130 см³ относительная эффективность для фотонов с $\epsilon_\gamma = 1332$ кэВ порядка 25%. Его энергетич. разрешение при этом в 50 раз лучше, чем у NaI(Tl).

Эффективность регистрации зависит от энергии γ -излучения ϵ_γ (кривая эффективности). В спектрометрии, режиме наиб. важна кривая фотоэффективности. Её обычно измеряют, используя т. н. образцовые спектрометрич. γ -источники с радионуклидами: ^{22}Na , ^{54}Mn , ^{27}Co , ^{60}Co , ^{45}Zn , ^{85}Sr , ^{109}Cd , ^{137}Cs , ^{131}I , ^{133}Ba , ^{137}Cs , ^{137}Cs , ^{147}Sm , ^{147}Sm , ^{203}Pb , ^{203}Pb , ^{241}Am и др. Для таких источников с высокой точностью определены активности радионуклидов, кол-ва γ -квантов в определ. спектральных линиях, измеряемые в А с в угле 4л. При исследовании внеш. среды, а также излучения человека используют образцовые объёмные источники, создаваемые часто на основе радиоакт. растворов.

В области энергии γ -квантов $\epsilon_\gamma = 200$ –2500 кэВ зависимость эффективности регистрации F от ϵ_γ описывается ф-лой:

$$\ln F = a_1 + a_2 \ln \epsilon_\gamma + a_3 (\ln \epsilon_\gamma)^2. \quad (5)$$

В частном случае полупроводникового детектора

$$\ln F + 25 = \ln F \frac{2}{\pi} \arctg[\exp(a_4 + a_5 \ln \epsilon_\gamma) + a_6 (\ln \epsilon_\gamma)^2], \quad (6)$$

где a_1, \dots, a_6 — численные коэффициенты. При замене одного детектора другим эффективность в пике полного поглощения ($\epsilon_\gamma \leq 3$ МэВ) определяется соотношением:

$$\ln F = \text{const} + S \ln \epsilon_\gamma, \quad S = a \ln V_{\text{акт}} + b, \quad (7)$$

где $V_{\text{акт}}$ — активный объём детектора, $a = 0,6246$; $b = -2,136$. Для диапазона энергий $\epsilon_\gamma = 60$ –3050 кэВ при измерении в чашечках Петри и в сосудах Маринелл эффективность описывается ф-лой:

$$\ln F = a_1 - [a_2 + a_3 \exp(-a_4 \epsilon_\gamma)] \exp(-a_5 \epsilon_\gamma) \ln \epsilon_\gamma. \quad (8)$$

Погрешности измерений. Потери счёта η в установках обусловлены мёртвым временем τ_m установ-

ки и неизбежностью случайных совпадений. Мёртвым временем τ_m наз. время нечувствительности детектирующей системы вслед за попаданием в неё частицы (фотона). Мёртвое время может быть пролевающимся явл. фиксированным. В первом случае $\eta = \exp(-\lambda \tau_m)$, во втором $\eta = (1 + \lambda \tau_m)^{-1}$, где λ — скорость счёта. Часто $\tau_m = f(n)$, напр. $\tau_m = a_0 + a_1 n$. Параметры a_0, a_1 определяют экспериментально с короткоживущими радионуклидами, напр. $^{113\text{m}}\text{In}$ ($T_{1/2} = 99,48$ мин).

В пике полного поглощения γ -квантов потери счёта могут вызываться одновременной регистрацией событий, произошедших в каскаде, и случайными совпадениями в пределах времени формирования сигнала. Величину η находят, измеряя спектры излучения при разных расстояниях источника от детектора.

Энергетическое разрешение. Мерой разрешающей способности спектрометрич. установки является полная ширина пика на половине высоты в распределении импульсов по энергии. Для сцинтиляционных детекторов её принято выражать величиной $\Delta E/E$ (%), для полупроводниковых — $\Delta \epsilon$. Для рентгеновского и γ -излучения приводит $\Delta \epsilon$ для энергий $\epsilon_\gamma = 5,9$ кэВ, 122 кэВ и 1332 кэВ.

Чувствительность. Мин. детектируемая концентрация (МДК) радионуклида (в Бк/кг⁻¹) в источнике выделяется ф-лой

$$\text{МДК} = \frac{2}{K_1 K_2 M} \sqrt{\frac{B}{t}}. \quad (9)$$

Здесь M — масса пробы, K_1 — коэф., учитывающий выход регистрируемого излучения на 1 акт распада радионуклида, K_2 — эффективность регистрации, B — скорость счёта фона, t — время измерений.

Радиационная «значимость» радионуклидов. Для оценки радиац. воздействия разл. радионуклидов применяют два метода: оценивают вклад радионуклида в индивидуальную усреднённую годовую дозу и э д л у ч е н и я для критич. группы людей — лиц, находящихся в наилучших условиях с точки зрения радиац. воздействия (табл. 1); оценивают вклад этого радио-

Табл. 1. — Связь усреднённой годовой дозы, содержащейся в продуктах питания, с удельной активностью некоторых радионуклидов

Радионуклид	Объект	Концентрация радионуклидов, ведущая к э эквив. дозе 10 мкЗв в 1 г (в критич. группе), Бк/д, Бк/кг		
^{14}C ^{14}C $^{238}\text{Pu} + ^{239}\text{Pu}$ ^{14}C ^{137}Cs ^{137}Cs	Молоко	8 20 0,3 0,4 0,5 0,5		
	^{60}Co $^{238}\text{Pu} + ^{239}\text{Pu}$ ^{137}Cs ^{137}Cs	Рыба	10 3 4 5	
		^{60}Co ^{147}Sm ^{147}Sm	Пашинные животные (ранн. черепки и др.)	200 200 70

нуклида в популяционную дозу. За концентрацией отд. радионуклидов, дающих вклад в годовую дозу, на уровне 10 мкЗв устанавливается систематич. наблюдение. Проводится паспортизации состояния окружающей среды с последующим наблюдением за скоростью нарастания содержания радионуклидов.

Фон. Для определения малых концентраций радионуклидов необходимо уменьшение радиационного фона, что достигается защитой. В табл.2 приведены осн.

Табл. 2.

ϵ_T , кэВ	Радионуклид	Интенсивность линии, %	Снижение фона защитой, во сколько раз
238,59	²¹⁴ Pb	45	330
325,99	²¹⁴ Pb	38,7	2700
583,14	²¹⁴ Pb	30,96	630
609,31	²¹⁴ Pb	48,9	3600
911,2	²¹⁴ Pb	27	2800
1401,2	²¹⁴ Pb	0,69	7
1120,29	²¹⁴ Bi	15,3	11000
1178,21	²¹⁴ Bi	100	24
1238,11	²¹⁴ Bi	6,05	2000
1322,47	²¹⁴ Bi	100	24
1460,75	²¹⁴ Bi	10,5	16000
1820,62	²¹⁴ Bi	1,43	1100
1764,5	²¹⁴ Bi	16,1	5600
2614,47	²¹⁴ Pb	36	1800

у-лучи, встречающиеся в радиац. фоне, и указано снижение фона защитой (результат эксперимента), выключающей слой Cd (толщиной 1 мм для защиты от нейтронов) Pb (10 см), Cu (4 см) (см. Радиационная защита). На установке, размещенной в соляной шахте на глуб. 305 м был получен фон $N = 1,7 \cdot 10^3$ импульсов на 1 кэВ на 1 см² чувствит. объема детектора за 1000 ч работы при энергиях γ -квантов $\epsilon_T = 2$ МэВ. В случае т. н. активной защиты осн. детектор окружат неск. вспомогательными детекторами. Осн. и вспомогат. детекторы включат в схему антисовпадений. Активная защита в виде пластмассового сцинтиллятора толщиной ~10 см внутри сцинтилляторной защиты толщиной 45 см, с многоканальным полупроводниковым детектором Ge(Li) позволила получить фон $N = 1,9 \cdot 10^4$ импульсов на 1 кэВ на 1 см² чувствит. объема детектора ($\epsilon_T = 2$ МэВ, $t = 1000$ ч).

Лит.: Jäckel B., Westmeier W., Pätzelt P., Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Research, 1987, v. A 261; Válo E., Gonzalez L., Gaeta R. and Gonzalez Y. A., «Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Research», 1975, v. 123; Cao Zhong, «Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Research», 1987, v. A 262; Salazar R. Reyes A. F., Fabra M. J., Baró I. and Tejada J., «Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Research», 1987, v. B 28; Fry F. A., «Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Research», 1984, v. 223; Liguori C., Sarracino A., Sverzelitti P. P. and Zanotti L., «Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Research», 1983, v. 204. В. А. Балажюк.

РАДИОНАВИГАЦИЯ — определение местоположения движущегося объекта (морских и воздушных судов, наземного транспорта и космич. аппаратов) с помощью радиотехн. устройств, расположенных на объекте и в окружающем пространстве в точках с известными координатами. В более узком смысле под Р. понимают определение к-л. параметра движения, напр. скорости или направления движения. В более широком смысле Р. включает и элементы управления движением, напр. выбор курса.

Для Р. могут использоваться 3 независимых навигац. параметра: дальность, радиальная скорость и угол, определяемые относительно заданной системы координат. Опорными точками системы координат являются радионавигат. станции, расположенные на поверхности Земли (с постоянными и известными координатами) или на ИСЗ, кораблях и самолетах, координаты к-рых изменяются, но точно известны в любой момент времени. Геом. место точк. соответствующие одинаковым значениям навигац. параметра в пространстве, зав. поверхностью положения, а на плоскости — линией положения. Пересечение трёх поверхностей или двух линий положения определит координаты объекта. В зависимости от измеремых навигац. параметров могут использоваться 3 осн. метода определения координат.

Дальномерный метод. Параметром является расстояние R_i между опорной точкой и объектом, поверхность положения — сфера радиусом R_i и центром в опорной точке. Координаты объекта (x, y, z) определяются при решении системы трёх ур-ний:

$$R_i = [(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2]^{0,5},$$

где x_i, y_i, z_i — известные координаты трёх ($i = 1, 2, 3$) опорных точек, а R_i — измеренные расстояния от объекта до опорной точки.

Для измерения расстояния передатчик объекта посылает радиомпульс запроса, на опорной точке его принимают и переизлучают. Измерив интервал времени T между моментами послыки запроса и приёмом переизлучённого импульса, определяют $R = c \cdot 0,5 \cdot T$, где c — скорость распространения радиоволн. Недостаток этого метода — огранич. пропускная способность навигац. системы, к-рая не может одновременно отвечать на запросы неск. объектов, устраиваемых при установке в опорных точках и на каждом объекте высокостабильных синхронизиров. эталонов времени (см. Квантовые стандарты частоты). В этом случае передатчики опорных точек в условленные моменты времени излучают радиомпульсы, к-рые принимают на объектах и определяют интервал времени, прошедший с условного момента до момента приёма радиомпульса. Осн. недостаток беззапросного метода — необходимость поддерживать чрезвычайно высокую точность синхронизации всех часов навигац. системы, т. к. каждая мкс расхождения шкал времени объекта и опорных точек даёт ошибку в определении расстояния $\Delta R = c \Delta T \approx 300$ м. Для исключения сдвига шкалы времени ΔT объекта относительно шкалы единого времени опорных точек применяют псевдодальномерный метод, заключающийся в измерении параметра R_i до четырёх ($i = 1, 2, 3, 4$) опорных точек. Решение системы четырёх ур-ний

$$c(T_i + \Delta T) = [(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2]^{0,5}$$

позволяет определить три неизвестные координаты объекта при известном сдвиге шкал ΔT .

Радиально-скоростной (доплеровский) метод. Параметром является радиальная скорость объекта относительно опорной точки, зависящая от координат и относительной скорости объекта:

$$\dot{R}_i = [(x_i - x)(\dot{x}_i - \dot{x}) + (y_i - y)(\dot{y}_i - \dot{y}) + (z_i - z)(\dot{z}_i - \dot{z})] / R_i.$$

При известных параметрах опорных точек и скорост. скорости объекта независимые измерения радиальных скоростей относительно трёх опорных точек позволяют определить координаты объекта. Измеряя доплеровское смещение F излучаемого передатчиком сигнала с частотой f , находят радиальную скорость $R \approx cF/f$ (см. Доплера эффект). Ошибку в определении F , возникающую из-за отклонения частоты эталона на объекте от частоты излучения передатчиков в опорных точках, можно исключить, применяя псевдодоплеровский метод, при к-ром измерятся дополнительные навигац. параметр по четвёртой опорной точке (так же, как и в псевдодальномерном методе).

Угломерный метод. Параметром является угол между направлениями на разл. опорные точки. Определение направления на источники радиозлучения осуществляется методами радиопеленгации.

Наряду с тремя осн. методами при построении радионавигат. систем широко применяют комбинац. метода типа дальномерно-доплеровского, дальномерно-угломерного и т. п. Нек-рые навигац. задачи решаются радиолокац. методами (см. Радиолокация), а при использовании в качестве опорных точек небесных тел — радиостр. методами (см. Радиостромолия).

Помимо метода определения координат объекта важной характеристикой любой радионавигат. системы является диапазон рабочих частот. В условиях Земли

рабочая длина волны определяет потенц. дальность действия навигат. системы, под к-рой понимается макс. расстояние, в к-ром обеспечивается заданная точность измерений. Она будет ограничиваться случайными изменениями скорости распространения радиоволн (дальнометрический и доплеровский метод) и направлением их прихода (угломерный метод). Учетная условия распространения радиоволн, для ближней Р. применяют ультракороткие волны, а для глобальной Р. (в пределах всей Земли) — сверхдлинные волны. Спутниковые системы Р. работают только в УКВ-диапазоне (см. *Распространение радиоволн*).

Лит.: Белаиов О. В., Основы радионавигации, 2 изд., М., 1977; Шебалин В. С. и др., Сетевые спутниковые радионавигационные системы, М., 1982; Шкляр В. В., Радионавигационные системы и устройства, М., 1984.

РАДИОНУКЛИДЫ — радиоакт. ядра (атомы). Их различают по типу радиоакт. распада (см. *Радиоактивность*). Т. к. α - и β -распады ядер обычно сопровождаются испусканием рентг. или γ -квантов, то большинство Р. являются источниками этих излучений, напр. ^{60}Co , широко используемый в медицине и технике. Число частых α - и β -излучателей невелико: ^3H (Т), ^{14}C , ^{238}Pu и нек-рые др.

Общее число известных Р. > 1800 (см. цветную вклейку в 3-м т.), и оно непрерывно растёт из-за синтеза новых Р. (см. *Трансураниевые элементы*).

В зависимости от устойчивости Р. подразделяются на короткоживущие и долгоживущие; принято, что Р. с периодом полураспада $T_{1/2} < 10$ сут относятся к короткоживущим. В связи с развитием экспресс. техники всё большее практич. значение приобретают Р. с малыми $T_{1/2}$ (всек. с или десятки с), напр. ^{16}N ($T_{1/2} = 7,13$ с); ^{16}O ($T_{1/2} = 27$ с). Полный распад таких Р. происходит за нек-рые мин, поэтому они практически безвредны, с их помощью можно исследовать пищевые продукты, потребительские товары и т. д. (см. *Радиометрия*).

Согласно действующим нормам радиационной безопасности (НРБ), все Р. подразделяются по радиотоксичности на 4 группы. К группе А относятся особо опасные Р. Это Р. тяжёлых элементов, ядра к-рых испытывают спонтанное деление или α -распад, имеющие сравнительно большие $T_{1/2}$. Такие Р. способны накапливаться в жизненно важных органах человека (^{210}Po ; изотопы Рn с А = 238, 239, 240, 242; ^{232}Cf и др.). К группе Б с высокой токсичностью относят ^{90}Sr , ^{106}Ru , ^{131}I , ^{144}Ce , ^{235}U и др. К группе В со ср. радиотоксичностью относят ^{45}Ca , ^{60}Co , ^{95}Zr и др. В группу Г входят Р. с малой токсичностью (^{14}C , ^3H и др.).

Р. могут быть природными (естественными) или искусственно полученными (техногенными). У природных долгоживущих Р. период распада сравним с возрастом Земли. Природные короткоживущие Р. или являются членами природных радиоакт. рядов, или непрерывно образуются за счёт ядерных реакций, обусловленных космич. излучением. Напр., ядра ^{14}C непрерывно образуются в результате радиационного захвата нейтронов космич. излучения ядрами ^{14}N атм. воздуха ($^{14}\text{N}(n,p)^{14}\text{C}$) или в результате деления ядер урана под действием нейтронов. В результате в природе (в исчезающе малых кол-вах) постоянно присутствуют Тс, Рn, Рn, Нр, Рn.

Значит. кол-ва техногенных Р. образуются при работе ядерных реакторов. Они возникают при делении ядер ^{235}U и ^{239}Pu . Для получения Р. используют также др. нейтронные источники. В т. н. изотопных генераторах можно отделять постоянно накапливающийся «дочерний» Р. от более долгоживущего материнского.

С. С. Бердосов, РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА — устройства для формирования радиосигналов, предназначенных для передачи информации на расстояние с помощью радиоволн.

Р. у. формируют радиосигналы с заданными характеристиками, необходимыми для работы конкретных радиотехн. систем, и излучают их в пространство. В лдбых Р. у. осуществляются следующие осн. физ. процессы: генерация эл.-магн. колебаний в заданном участке радиодиапазона; управление параметрами этих колебаний (амплитудой, частотой, фазой, поляризацией и т. д.) по закону передаваемой информации (амплитудный, частотный и др. виды модуляции; см. *Модуляционные колебания*); излучение радиосигналов в пространство при помощи антенны, связанной с генератором электромагнитных колебаний либо непосредственно, либо через линию связи. Помимо создания радиосигналов, предназначенных специально для передачи информации, Р. у. применяются в системах радионавигации, дистанц. зондирования земной поверхности и др. целей.

Структурные схемы Р. у. различны в зависимости от требований к характеристикам формируемых в них радиосигналов. Типовые Р. у. для радиовещания с амплитудной (АМ) или частотной (ЧМ) модуляцией строятся обычно по многокаскадной схеме (рис. 1, а, б).

Генерирование высокостабильных первичных колебаний осуществляется в спец. устройствах — возбудителях Р. у. Иногда (напр., при ЧМ) формирование радиосигналов производится сразу путём модуляции первичных колебаний. В качестве простых возбудите-

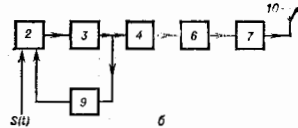
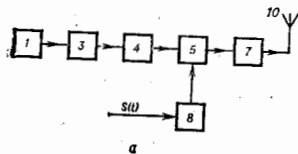


Рис. 1. Типовые структурные схемы радиопередающих устройств с амплитудной (а) и частотной (б) модуляцией: 1 — задающий генератор, стабилизированный кварцем (возбудитель); 2 — частотно-модулируемый возбудитель; 3 — буферный усилитель; 4 — каскады умножения частоты; 5 — модулируемый каскад; 6 — промежуточный усилитель; 7 — выходной усилитель мощности; 8 — модулятор; 9 — система автоподстройки центральной частоты; 10 — антенна.

лей используются автогенераторы на транзисторах, лампах-пролетных диодах и т. д. Поскольку частота автоколебаний, близкая к собств. частоте колебательной системы, зависит от режима работы активного элемента, принимаются жёсткие меры по защите всех элементов автогенератора от влияния дестабилизирующих факторов. Мин. достижимый уровень нестабильности частоты автогенератора ограничен шумами, т. е. естеств. флуктуациями фазы и амплитуды автоколебаний (см. *Стабилизация частоты*). В совр. Р. у. с быстрой электронной перестройкой в широком диапазоне рабочих частот в качестве возбудителей колебаний используются синтезаторы частот — устройства, генерирующие множество высокостабильных колебаний на дискретных частотах, синтезируемых из колебаний одного прецизионного кварцевого генератора или кварцевого стандарта частоты. Схемы синтезаторов строятся с использованием систем автоподстройки частоты и фазовой синхронизации колебаний.

Для ослабления влияния последующих каскадов на режим работы возбуждителей колебаний в схеме Р. у. включают т. п. буферные усилители, потребляющие мин. мощность сигнала от автогенератора. Часто в тех же целях прибегают к уменьшению частоты задающего генератора, что одновременно повышает устойчивость работы Р. у. в целом. В качестве нелинейных элементов в каскадах уменьшения частоты используют ВЧ-транзисторы, протёные *клинстры* и др. активные приборы. В диапазоне СВЧ находят применение полупроводниковые диоды (*варикапы*).

Выходные усилители мощности Р. у., связанные с антенной непосредственно или через линию связи, обеспечивают заданную излучаемую мощность. Эти усилители строятся по схеме генератора с внеш. возбуждением, и в качестве активных элементов в них используются мощные транзисторы или металлокерамич. электронные лампы (часто с принудит. охлаждением электродов). В диапазоне СВЧ применяются протёные *клинстры* и усилительные приборы с распределённым взаимодействием — *лампы бегущей волны* и *лампы обратной волны*.

Управление параметрами колебаний в соответствии с передаваемой информацией $S(t)$ производится с помощью модуляторов. АМ в маломощных вещательных Р. у. осуществляется, напр., изменением по закону $S(t)$ управляющего напряжения на активном элементе; затем происходит усиление модулиров. колебаний. В радиолокации, радиорелейных линиях связи и мн. др. системах широко применяют разновидность АМ — импульсную модуляцию (ИМ). При ИМ высокочастотные колебания на выходе Р. у. вырабатываются лишь в течение коротких интервалов времени (импульсов), раздвоенных большими или меньшими паузами. В мощных импульсных модуляторах используется метод накопления энергии (или магн.) энергии в ёмкостях (или индуктивных) накопителях. Накопление энергии происходит во время паузы с последующим разрядом накопителя на генератор через электронный или газоразрядный коммутатор.

Угл. модуляции (частотная, ЧМ, или фазовая, ФМ) повышает помехоустойчивость системы связи. Для осуществления ЧМ т. н. прямым методом осуществляется электронная перестройка частоты колебаний задающего автогенератора по закону $S(t)$ (рис. 1, 6). При этом для стабилизации несущей частоты используется система автоподстройки, к-рая корректирует медленные уходы частоты автогенератора, вызванные дестабилизирующими факторами. При косвенном методе ФМ применяются высокостабильные задающие внешние автогенераторы и производится фазовая модуляция их колебаний. При этом сохраняется высокая стабильность центральной частоты, однако полезная девиация частоты ЧМ колебаний на низких модулирующих частотах мала.

Для переноса информации в виде ЧМ, а не в виде ФМ модулирующее напряжение, пропорциональное $S(t)$, подается на модулятор фазы не непосредственно, а через интегратор.

В СВЧ- и ВЧ-диапазонах, а также в оптич. диапазоне реализация Р. у. по многокаскадной схеме затруднена и Р. у. часто выполняются по однокаскадной схеме с мощным автогенератором, совмещающим ф-цию возбуждения, модулятора и выходного каскада.

Для существенного повышения мощности Р. у. прибегают к сложению мощностей неск. активных элементов, соединяя их параллельно или последовательно с нагрузкой. В сверхмощных Р. у. мощную ступень выводят по системе блоков — отд. выходных каскадов, общей нагрузкой к-рых является промежуточный контур, связанный с антенной. Недостатки подобных соединений активных элементов обусловлены взаимной связью их через нагрузку и источник возбуждения. Мостовое включение активных элементов существенно ослабляет взаимную связь между ними. Мост-делитель,

выполненный из реактивных элементов, распределяет входную мощность поровну между активными элементами, а мост-сумматор складывает их мощность в общей нагрузке.

Эфф. сложение мощности мн. генераторов для формирования сигналов в заданной области пространства реализуется с помощью фазированных антенных решёток (ФАР), содержащих большое число (до неск. тыс.) излучающих элементов и каналов для их возбуждения (рис. 2). Форму и положение узкого лепестка *диаграммы направленности* в Р. у. с ФАР можно быстро и точно изменять с помощью электронно управляемых фазовращателей, линий задержки и коммутаторов.

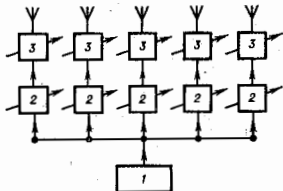


Рис. 2. Структурная схема радиопередающего устройства с фазированной антенной решёткой: 1 — возбуждатель сигнала; 2 — каналы управления задержкой; 3 — усилители мощности.

В Р. у. оптич. и частично СВЧ-диапазонах используются квантовые генераторы и усилители (см. *Лазер*). Для модуляции интенсивности оптич. излучения (когерентного или некогерентного) разработаны простые электронно-оптич. модуляторы. Нестабильность частоты колебаний квантовых генераторов за счёт слабости взаимодействия микрочастиц чрезвычайно мала (порядка 10^{-10} — 10^{-12}). В качестве канала связи в оптич. диапазоне широко применяются волоконно-оптич. кабели из спец. стекловолокна или др. диэлектрика с чрезвычайно широкой полосой пропускания частот (до 10 ГГц/км) и слабым затуханием энергии света (5 дБ/км и менее).

Классификация Р. у. возможна по разным признакам: по назначению, диапазону рабочих частот, мощности. Различают Р. у. радио- и телевизионного вещания, профессиональной и космич. радиосвязи, навигационные, телеметрические, радиолокационные, Р. у. радиоуправления и т. д. Совр. Р. у. охватывают спектр ул.-магн. колебаний от очень низких (3—30 КГц) до крайне высоких (30—300 ГГц) частот. По мощности выделяют Р. у. очень малой ($P \leq 3$ Вт), малой (3—100 Вт) и средней (0,1—10 кВт) мощности, а также мощные (до 1000 кВт) и сверхмощные (св. 1000 кВт).

По виду модуляции различают Р. у., работающие в непрерывном режиме с амплитудной, частотной, фазовой модуляцией или их сочетаниями, и импульсные Р. у. с разл. видами модуляции параметров радиоимпульсов — амплитудно-импульсной, широтно-импульсной, кодомпульсной и др. Частый случай импульсной модуляции — манипуляция используется при передаче телеграфных знаков. В условиях воздействия мощных помех применяют шумоподобные сигналы.

По типу активных элементов, используемых для формирования радиосигналов в разл. диапазонах рабочих частот и мощностей, различают Р. у. транзисторные, ламповые, клинстронные, магнетронные, на лампах бегущей волны или обратной волны, лазерные и т. д.

Техн. характеристики Р. у. определяются требованиями к радиосистеме, в составе к-рой они работают. Важнейшей характеристикой является точность фиксации положения спектра частот радиосигнала, определяемая нестабильностью несущей частоты.

Нормы на стабильность частоты Р. у. жестки и зависят от диапазона частот, назначения и мощности Р. у. Напр., в диапазоне 4,0—28,7 МГц для стационарных вещательных и связанных Р. у. допускается $\Delta f/f \leq 5 \cdot 10^{-7}$ при мощности $P < 500$ Вт и $\Delta f/f \leq 1,5 \cdot 10^{-7}$ при $P > 500$ Вт. В др. системах требования к стабильности частоты Р. у. могут быть ещё выше.

Наряду с осн. рабочими колебаниями на выходе Р. у. возникают нежелат. побочные колебания, спектр к-рых находится за пределами полосы сигнала. Нормы на побочные излучения определяются условиями эл.-магн. совместимости радиотехн. средств. Требования к допустимому их уровню зависят от назначения и мощности Р. у., повышаясь с ростом мощности. По существующим требованиям $P_{\text{поб}}/P_{\text{осн}} < -40$ дБ при $P_{\text{осн}} < 0,5$ Вт, $P_{\text{поб}}/P_{\text{осн}} < -60$ дБ при 40 Вт $< P_{\text{осн}} < 1$ кВт и $P_{\text{поб}}/P_{\text{осн}} < -90$ дБ при $P_{\text{осн}} > 1000$ кВт для Р. у. в диапазоне 30—235 МГц. Абс. уровень мощности любого побочного излучения Р. у. не должен превышать $25 \cdot 10^{-8}$ — $1 \cdot 10^{-8}$ Вт в зависимости от диапазона частот, мощности и назначения Р. у.

Важной характеристикой Р. у. является величина кд η — отношение $P_{\text{осн}}$ к полной мощности, потребляемой Р. у. от источника питания. Так, для вещательных Р. у. в режиме отсутствия модуляции $\eta = 60\%$, в Р. у. межконтинентальной связи на длинных волнах при очень большой мощности (500—2000 кВт) в телеграфном режиме достигается $\eta = (50-60)\%$.

Осн. направления развития Р. у. имеют след. тенденции: дальнейшее освоение новых диапазонов частот и достижение больших мощностей Р. у. с помощью более совершенных активных элементов и новых способов генерирования эл.-магн. колебаний; разработка принципов объединения Р. у. с включающей системой в единое целое; развитие технологии и методов интегрального исполнения узлов и Р. у. в целом; применение в Р. у. для формирования радиосигналов и управления режимами работы элементов цифровой техники и микропроцессоров.

Лит.: Вятянов С. И., Радиопередающие устройства, М., 1950; Проектирование радиопередающих устройств, под ред. В. В. Шахматова, М., 1978; Проектирование радиопередающих устройств СВЧ, под ред. Л. М. Утмана, М., 1978; Радиопередающие устройства, под ред. М. В. Благочестного, Г. М. Утмана, М., 1982. М. В. Натанов.

РАДИОПРИЕМНИКИ СВЧ — радиоприёмные устройства, предназначенные для работы в диапазоне радиоволн от 300 МГц до 3000 ГГц (в диапазоне СВЧ). Р. СВЧ подразделяются по рабочему диапазону — на Р. СВЧ дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн, а также по схеме построения — на Р. СВЧ прямого усиления, супергетеродинные (см. Супергетеродин) и детекторные (см. Детекторирование). Радиоприёмники могут быть охлаждаемыми и неохлаждаемыми. В большинстве случаев Р. СВЧ строят по супергетеродинной схеме, т. к. обычно эта схема обеспечивает наивысшую чувствительность и в практических легче реализуется, чем схема прямого усиления. Детекторные Р. СВЧ получили применение гл. обр. в диапазонах дециметровых волн и построены на основе криогенно охлаждаемых болометров и полупроводниковых объёмных детекторов. В сантиметровом и миллиметровом диапазонах (до частоты $f = 230$ ГГц) в большинстве случаев используются неохлаждаемые Р. Более коротковолновые Р. СВЧ, причём часто охлаждаемые, применяют только в научных исследованиях.

В Р. СВЧ в качестве нелинейных активных элементов для генерирования, усиления и преобразования СВЧ-колебаний применяют полупроводниковые элементы, размеры к-рых до частот $f = 150$ ГГц значительно меньше длины волны λ . Канализация СВЧ-колебаний в Р. СВЧ осуществляется разл. видами линий передачи. Для подключения к антенне или измерит. аппаратуре в диапазонах $\lambda < 2$ мм часто используются микрополосковая или несимметричная полосковая линия, щелевая, компланарная и волноводно-щелевая линии

с переходом на прямоуг. металлч. волновод (рис. 4); на коротких миллиметровых волнах и в дециметровом диапазоне для канализации СВЧ-колебаний — односторонние и многомодалые (см. Моды) прямoug. волноводы

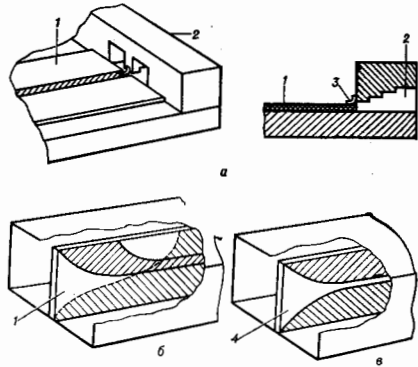


Рис. 1. Элементы конструкции линий передачи СВЧ с переходом на прямоуг. волноводы: а, б — микрополосковая линия, в — щелевая, волноводно-щелевая линия; 1 — микрополосковая плата (диэлектрическая пластина с пленочными металлическими проводниками на обеих сторонах); 2 — прямоуг. волновод со ступенчатым переходом к П-волноводу; 3 — соединительная металлическая лента; 4 — диэлектрическая пластина с пленочными проводниками.

и квазиопт. структуры (рис. 2, 3). Для Р. диапазонов $\lambda \approx 2-0,5$ мм наблюдается тенденция перехода от сосредоточенных приёмных элементов к распределённым, от волноводных элементов согласования потока излучения с приёмным элементом к оптическим. В этом диапазоне ограничения предельной чувствительности обусловлены гл. обр. не тепловыми флуктуациями, а квантовыми. Примерами сосредоточенных приёмных элементов, в к-рых используют волноводные элементы

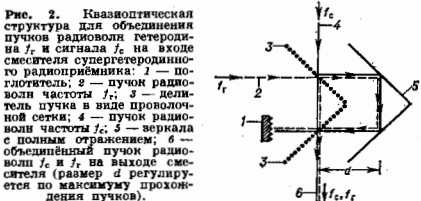


Рис. 2. Квазиоптическая структура для объединения пучков радиоволн гетеродина f_1 и сигнала f_2 на входе смесителя супергетеродинного радиоприёмника: 1 — доплыв частоты f_1 ; 2 — делитель пучка в виде проволочной сетки; 3 — пучок радиоволн частоты f_2 ; 4 — волновод с полным отражением; 5 — объединённый пучок радиоволн f_1 и f_2 на выходе смесителя (размер d регулируется по максимуму прохождения пучков).

согласования, являются полупроводниковые усилители СВЧ на полевых транзисторах Шоттки (ПТШ) или параметрические усилители на полупроводниковых диодах, смесители на диодах Шоттки (см. Диоды твердотельные) или контактах сверхпроводник — изолятор — сверхпроводник (СИС-смесители). Детектор на InSb, а также полупроводниковые и сверхпроводниковые болометры представляют собой примеры распределённых (объёмных) приёмных элементов с использованием квазиопт. методов согласования (см. Квазиоптика).

Наиб. важные параметры Р. СВЧ — коэф. шума (шум-фактор) F (для эфф. шумовой темп-ры $T_{\text{ш}}$) (рис. 4) и полоса рабочих частот Δf (длина волн $\Delta \lambda$). Шумовые

параметры F и $T_{ш}$ связаны соотношением $F = 1 + T_{ш}/T_0$, где $T_0 = 293$ К. Входные малошумящие усилители (МШУ) Р. СВЧ созданы до частот $f =$

(ГИС) и монолитных интегральных схем. На частотах $f > 150$ ГГц применяют волноводные (рис. 5) и квазиоптич. коллекция СДШ (рис. 2).

Рис. 3. Квазиоптическая структура для детекторного радиоприёмника с распределённым полупроводниковым приёмным элементом: 1 — световод; 2 — держатель; 3 — приёмный элемент; 4 — иммерсионная линза из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, такой же, как у приёмного элемента; 5 — проводник для подачи смещения на приёмный элемент и вывода напряжения детектируемого сигнала.

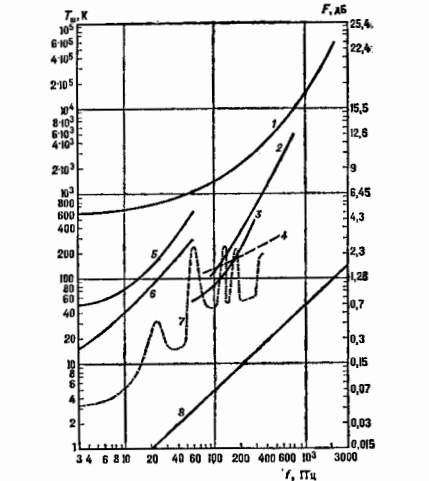
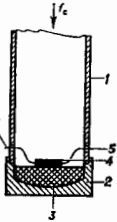


Рис. 4. Частотная зависимость минимальных шумовых параметров радиоприёмников и их малошумящих входных каскадов: 1 — неохлаждаемые смесители на диодах Шоттки; 2 — охлаждаемые до 20 К смесители на диодах Шоттки; 3 — сверхпроводниковые СИС-смесители, охлаждаемые до 2 К; 4 — смесители на InSb, охлаждаемые до 4 К; 5 — неохлаждаемые малошумящие усилители на полевых транзисторах Шоттки; 6 — усилители, охлаждаемые до 20 К; 7 — шум атмосферы; 8 — квазитовый шум.

$= 100$ ГГц, однако практич. использование в технике в осн. получили только МШУ до $f \approx 40$ ГГц, причём наиб. эффективными по совокупности характеристик являются МШУ на ПТШ, к-рые повсеместно вытесняют др. виды МШУ, в т. ч. в миллиметровом диапазоне радиоволн. Охлаждение МШУ на этих транзисторах приводит к существенному снижению величин $T_{ш}$. Из разновидностей входных каскадов Р. СВЧ ближайший к МШУ на ПТШ по величине шумовых параметров смеситель на диодах Шоттки (СДШ), к-рый является самым распространённым малошумящим входным каскадом Р. СВЧ и наиб. продвинутым в КВ-часть радиодиапазона. В своих диапазонах частот СДШ, как и др. функциональные элементы и узлы Р., изготавливают методами микроэлектроники в виде гибридно-интегральных схем

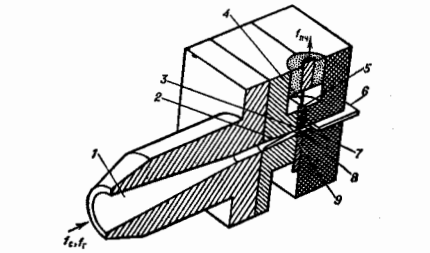


Рис. 5. Смеситель на диодах Шоттки: 1 — рупорная антенна для ввода колебаний сигнала и гетеродина; 2 — конусный переход от круглого волновода к прямоугольному; 3 — кристалл диода Шоттки соевой структуры; 4 — проводящий слой сигнала; 5 — фильтр низкой частоты на отрезок номинальной длины с высоким и низким волновым сопротивлением; 6 — подвижный настроенный короткозамыкающий поршень; 7 — прямоугольный волновод пониженной высоты; 8 — контактная пружинка и чашка диода Шоттки; 9 — опорный штифт контактной пружиной.

Преобразование частоты осуществляется в смесителе при подведении к нему мощности гетеродина. Большинство гетеродинов, применяемых в СВЧ-диапазоне, создаются на основе полупроводниковых активных элементов — диодов и транзисторов. Для создания гетеродинов на частотах $f \geq 10$ ГГц используют в осн. 2 вида диодов — Ганна диоды (ДГ) и диоды Шоттки, а также ПТШ. На основе ДГ создают автогенераторы (см. Генератор электромагнитных колебаний), использующие отрицательное дифференциальное сопротивление, возникающее в ДГ. Геттердины на диодах Ганна (ГДГ) также являются самым распространённым видом гетеродиного автогенератора в диапазоне 10—150 ГГц благодаря своей миниатюрности, экономичности и малым шумам. Они могут быть с фиксиров. настройкой (со стабилизацией частоты и без неё) и с механич. или электр. перестройкой частоты, к-рая в последнем случае часто осуществляется с помощью нелинейной ёмкости, включаемой в колебательный контур (систему) генератора. Обычно в качестве такой ёмкости применяют полупроводниковый диод (напр., диод Шоттки). Для стабилизации частоты используют высокочастотный объёмный резонатор, чаще в виде диэлектрич. резонатора (рис. 6). Для создания гетеродинов на частотах $f > 150$ ГГц применяют умножители частоты на диодах Шоттки. Такие умножители частоты (удвоители, утроители) конструктивно сложны и содержат элементы СДШ. Транзисторные гетеродины на ПТШ в виде пере-

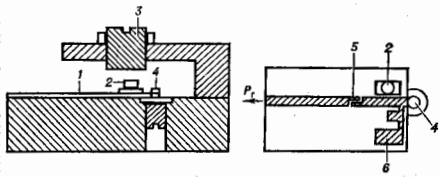


Рис. 6. Конструкция микрополосового гетеродина на диоде Ганна на $f=50$ ГГц: 1 — микрополосовая плата; 2 — диэлектрический резонатор в форме диска; 3 — вент. настроенный рабочей частоты; 4 — диод Ганна; 5 — СВЧ блокированный конденсатор; 6 — вывод для подачи постоянного напряжения питания.

страиваемых или стабилизированных автогенераторов, подобных ГДР, создаются и применяются в Р. в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. По сравнению с ГДР они более экономичны (выше КПД) и надежны. Во всех случаях с укорочением длины волны λ возрастает шум гетеродина и его влияние на величину F , а также трудности подавления зеркального канала приема на частоте $f_{\text{з}}$ расположенной симметрично частоте сигнала $f_{\text{с}}$ относительно частоты $f_{\text{Г}}$ ($|f_{\text{с}} - f_{\text{з}}| = 2f_{\text{Г}}$, где $f_{\text{Г}}$ — промежуточная частота). Поэтому в диапазоне миллиметровых и дециметровых волн применяют супергетеродинные радиоприемники с двойным преобразованием частоты, в к-рых имеются 2 преобразователя частоты (смесителя с гетеродином) и 2 усилителя промежуточной частоты. В результате первого преобразования получают первую (высокую) промежуточную частоту, лежащую в диапазоне СВЧ ($f_{\text{пч}} = 1-10$ ГГц), а после второго вторую (относительно низкую) промежуточную частоту ($f_{\text{пч}} = 30-200$ МГц), обычно используемую в Р. СВЧ с однократным преобразованием частоты. Благодаря высокой $f_{\text{пч}}$ увеличивается разброс частот $|f_{\text{с}} - f_{\text{з}}|$ и облегчается задача повышения селективности Р. СВЧ по зеркальному каналу (в радиотехнич. Р. СВЧ это не требуется). Одновременно уменьшается и вклад шума гетеродина в общий уровень шума на выходе первого смесителя. Это обусловлено тем, что уровень составляющих шумового спектра, сопровождающего несущее колебание гетеродина, уменьшается по мере удаления от несущей частоты (т. е. по мере увеличения $f_{\text{пч}}$); следовательно, будут малы и шумовые составляющие спектра гетеродина, преобразованные на $f_{\text{пч}}$ в едином процессе преобразования сигнала.

Детекторы в Р. СВЧ строятся на основе сосредоточенных детекторов на ДБШ и распределенных болометрах. Таковыми являются электронные болометры на разогрете электронов в полупроводнике l — InSb и сверхпроводниковых пленках, а также обычные болометры на разогрете материала болометра (напр., полупроводника Ge и сверхпроводниковых пленок). Осн. характеристики детекторов Р.: предельная чувствительность $F_{\text{пр}}$ (для возможности сравнения разл. детекторов Р. эта величина приводится к приёмной площадке $S = 1 \text{ см}^2$ и полосе усиления детектируемого сигнала $\Delta F = 1$ Гц); предельная частота модуляции принимаемого сигнала $F_{\text{пр}}$, при к-рой амплитуда детектируемого сигнала уменьшается в ϵ раз (в болометрах связана со скоростью отвода тепловой энергии от электронов в электронных болометрах или от всего приёмного элемента в обычных болометрах); рабочая температура; рабочий диапазон длин волн (табл.).

Тип приёмного элемента	$F_{\text{пр}}$, Вт	$F_{\text{пр}}$, Гц	$T_{\text{р}}$, К	Рабочий диапазон для волн
Сверхпроводниковый пленочный металл. болометр	$3 \cdot 10^{-11}$	1	1,4	мм, дм
Германиевый болометр Шоу	10^{-12}	10^2	1,5	мм, дм
Электронный болометр	$10^{-12}-10^{-14}$	10^4	4,2	$F_{\text{пр}}$ падает при $0,5$ мм, мм, дм
Электронный болометр на сверхпроводниковых пленках	10^{-11}	10^4	2,0	мм, дм
Детектор на ДБШ	$F_{\text{пр}} = 10^{-12}-10^{-16}$ (сосредоточенный в волноводе)	293	$F_{\text{пр}}$ падает на 2 порядка в диапазоне $1 \text{ см}-0,7 \text{ мм}$	

Области применения Р. СВЧ: радиолокация, радионавигация, радиосвязь, радиоспектроскопия и др. радиодиагностика, исследования, радиосвязь (радиорелейная, космич., спутниковая), спутниковое радио- и телевидение, радиометрия.

Лит.: В ы с т а в к и н А. Н., М и г у л и н В. В., Приемники миллиметровых и субмиллиметровых волн. «Радиотехника и электроника», 1967, т. 12, № 1, с. 1989; А р ч е р Д. К. У., Малошумящие гетеродинные приемники ближнего миллиметрового диапазона для радиотехнических наблюдений. СТИЭР, 1985, т. 1985, № 1, с. 114; Теоретические устройства СВЧ в технике связи, М., 1988; К а л а ч С. М., Радиоприемные устройства миллиметрового диапазона волн, в кн.: Итоги науки и техники. Сер. Радиотехника, т. 39, М., 1989; В ы с т а в к и н А. Н., К о п е л е ц В. Ш., О з л и н и к о в Г. А., Сверхширокополосные приемные устройства миллиметровых волн, М., 1989; Г е р с е н з о н Е. М. и др., О предельных характеристиках быстродействующих сверхпроводниковых болометров. СТИЭР, 1989, № 2, с. 114; А. Н. Выставкин, РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА — системы электр. цепей, узлов и блоков, предназначенные для улавливания распространяющихся в открытом пространстве радиоволн естеств. или искусств. происхождения и преобразования их к виду, обеспечивающему использование содержащейся в них информации. Первые Р. у. созданы в 90-х гг. 19 в.

Принцип действия Р. у. поясняется на обобщенной функциональной схеме (рис. 1). С помощью прямой антенны 1 происходит преобразование эл.-магн. волн

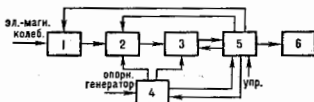


Рис. 1. Обобщенная функциональная схема радиоприемного устройства: 1 — прямая антенна; 2 — усилительно-преобразовательный тракт; 3 — информационный тракт; 4 — устройство управления и отображения; 5 — детектирующее устройство; 6 — оконечное устройство.

в электр. сигналы. В усилительно-преобразовательном тракте (УТ) 2 осуществляется выделение полезных сигналов из всей совокупности поступающих от антенны сигналов в помех и усиление первых до уровня, необходимого для нормальной работы последующих каскадов Р. у. Хотя в УТ с сигналами могут проводиться некоторые нелинейные процедуры — смещение спектра, ограничение амплитуды и др., в принимаемую информацию этот тракт существенных искажений не вносит и в этом смысле является линейным.

Информ. тракт (ИТ) 3 производит осн. обработку сигнала с целью выделения содержащейся в нём полезной информации (детектирование) и ослабления мешающего воздействия помех естеств. и искусств. происхождения.

Гетеродинный тракт (ГТ) 4 преобразует частоту собственного или внеш. опорного генератора электромагнитных колебаний и формирует дискретные множества частот, необходимые для преобразования частоты в УТ, для работы следящих систем и цифровых устройств обработки сигнала в ИТ, для перестройки Р. у. на др. входную частоту и т. п. (см. также Супергетеродин). Устройство управления и отображения 5 позволяет осуществлять ручное, дистанц. и автоматизиров. управление режимом работы Р. у. (включение и выключение, поиск сигнала, адаптация к изменяющимся условиям работы и др.) и отображает качество его работы на соответствующих индикаторах. В оконечном устройстве 6 энергия выделяемого сигнала выделяется для получения требуемого выходного эффекта — акустич. (телефон, громкоговоритель), оптич. (кинескоп, дисплей), механич. (печатательное устройство) и т. д. Существуют радиотехн. системы (РТС), в к-рых Р. у. содержат неск. приёмных антенн и УТ (разнесённый приём) или имеют ряд выходных каналов в оконечных устройствах (многочанальное Р. у.).

Классификация Р. у. определяется в первую очередь назначением соответствующих РТС: системы передачи информации (радиосвязь, радиове-

пание, телевидение, радиотелеметрия, радиоуправление; системы и в течение и информации (радиолокация, радионавигация, радиостроения, контроль природной среды); системы разрабатываются и формируются (радиопроходимость). Использование того или иного диапазона радиочастот и ширины спектра, отводимая для РТС разл. классов, регламентированы, что существенно влияет на выбор вида приемных радиосигналов, и как следствие — на построение и параметры Р. у.

По виду принимаемых сигналов Р. у. можно разделить на два крупных класса: для приема квазиогеревых сигналов или некогерентных, гл. обр. радиотепловых, излучений (см. *Когерентность, Радиометр*). К первому, более обширному классу относятся Р. у. систем передачи и разрушения информации, Р. у. активных радиолокац. и радионавигат. систем. Радиометры находят применение в радиотеллокации, радиостроении, при дистанц. контроле природной среды, для обнаружения объектов на фоновых поверхностях и т. д. В свою очередь, квазиогеревые сигналы можно разделить на непрерывные и импульсные. В непрерывных РТС Р. у. принимают информацию, отображаемую изменением параметров, модулицией амплитуды (АМ), частоты (ЧМ), фазы (ФМ) несущего непрерывного, обычно гармонического, сигнала (см. *Модулирование колебаний*). В импульсных системах приемный сигнал представляет собой последовательность радиоимпульсов, в к-рой информация могут нести изменяющиеся параметры как отд. импульсов, так и всей последовательности. В цифровых РТС приемное несущее колебание модулируется кодовыми группами импульсов, соответствующими определ. уровням передаваемого сигнала.

По функциональному назначению Р. у. делит на профессиональные и бытовые (бытовые). Последние обеспечивают приём программ звукового и телевизионного вещания и являются наиб. массовыми радиотехн. устройствами. Р. у. подразделяются также по месту установки (стационарные, бортовые, переносные), по способу управления и коммутации, по виду питания.

Различаются Р. у. и по мн. конструктивно-эксплуатат. и экономич. показателям: стабильности, точности и времени настройки, эргономичности, надёжности, ремонтпригодности, эвергетич. экономичности, массе и габаритам, стоимости, мобильности и др.

Основные параметры Р. у. Чувствительность Р. у. характеризует его способность принимать слабые сигналы и количественно определяется мн. эдс или помпальной мощностью P_A в антенне, при к-рых на выходе Р. у. сигнал воспроизводится с требуемым качеством. Под последним обычно понимается обеспечение либо нормального функционирования оконечного устройства при заданном отношении сигнал — шум на выходе Р. у., либо одного из вероятностных критериев принятого сигнала.

При приеме сравнительно сильных сигналов (незатеняемый приём), в условиях относительного слабого влияния помех чувствительность Р. у. ограничивается усилением УТ. Если сигнал и помехи соизмеримы, повышение усиления не приводит к росту чувствительности. Поскольку кроме веш. помех на выходе УТ всегда присутствуют помехи, обусловленные в осн. флукуатц. шумами (см. *Флукуатц.и электр.шумы*), предел чувствительности определяется последними. Реальная чувствительность Р. у. определяется соотношениями

$$P_A = P_{c,вх} = \frac{P_{ш,вх}}{K_p} D = kT_0 \Pi_{ш} K_{ш,пр} D;$$

$$E_A = \sqrt{4kT_0 \Pi_{ш} K_{ш,пр} D R_A},$$

где $T_0 = 293$ К, $\Pi_{ш}$ — шумовая полоса (полоса частот,

в к-рой оценивается интенсивность шумов), $K_p = \frac{P_{c,вх}}{P_{с,вых}}$ — коэф. усиления мощности УТ, $P_{с,вх}$, $P_{с,вых}$ — мощность сигнала соответственно на входе и выходе УТ, $D = \frac{P_{с,вх}}{P_{ш,вх}}$ — коэф. различимости, $P_{ш,вх}$ — мощность шумов на входе УТ, R_A — полное активное сопротивление антенны,

$$K_{ш,пр} = \frac{P_{с,пр}}{P_{ш,вх}} \frac{P_{ш,вх}}{P_{с,вх}}$$

коэф. шума Р. у., $P_{ш,вх}$ — мощность шумов на входе УТ. При $D = 1$ достигается пороговая чувствительность $P_{A,пор} = P_{ш,вх}/K_p$. Для оценки шумовых свойств малопомехных Р. у. используется также шумовая темп-ра $T_{ш,пр} = (K_{ш,пр} - 1) T_0$. Р. у. СВЧ имеют чувствительность $10^{-9} - 10^{-10}$ Вт или шумовую темп-ру 5—500 К, чувствительность Р. у. умеренно высоких частот находится в зависимости от назначения в пределах от десятых долей до тыс. мкВт.

Избирательность Р. у. называют его способность отделить полезный сигнал от мешающих, основанную на использовании отличий признаков полезных и мешающих сигналов: направления распространения и времени действия, поляризации, амплитуды, частоты и фазы. Пространственная и поляризац. избирательность достигается применением антенн с острой *диаграммой направленности* или с электронно-управляемым лучом (в фазированных антенных решетках), их настройкой на соответствующую поляризацию сигнала. Временная избирательность (при приеме импульсных сигналов) достигается отиранием Р. у. лишь на время действия полезного сигнала. Осн. значение имеет частотная избирательность, поскольку в большинстве РТС сигналы отличаются по частоте и их разделение осуществляется с помощью резонансных элементов, цепей и *фильтров электр.шумов* (см. также *Резонансный усилитель*). Различают односигнальную и многосигнальную избирательность.

Одосигнальная избирательность определяется амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ) избирательных цепей в УТ при действии на вход Р. у. только одного слабого сигнала — полезного или мешающего, не вызывающего нелинейных эффектов. Количественно избирательность оценивается чаще всего отношением, показывающим, во сколько раз усиление УТ (или отдельного его каскада) для полезного сигнала больше усиления для мешающего сигнала. Др. мерой оценки одосигнальной избирательности служит коэф. прямоугульн. усиления, равный отношению полос пропускания УТ (или отдельных его каскадов) при двух значениях нормированного коэф. усиления, обычно 3 дБ и 60 дБ: чем ближе этот коэф. к единице, тем больше АЧХ реального каскада совпадает с идеальной прямоуг. характеристикой и тем выше одосигнальная избирательность.

Обычно приём слабого сигнала осуществляется на фоне одной или неск. значительных по уровню внеполосных помех (т. е. помех, не попадающих в полосу пропускания Р. у.), при этом начинает проявляться нелинейность УТ и его АЧХ уже не полностью характеризует реальную избирательность Р. у., для оценки к-рой используется многосигнальная (двух- и трёхсигнальная) избирательность. Нелинейные эффекты в УТ обусловлены гл. обр. нелинейные вольтамперной характеристикой его активных элементов (диодов, транзисторов и др.) при больших уровнях сигнала или помех и вызывают такие явления, как интермодуляция, перекрестные искажения, блокирование, сжатие амплитуды. Интермодуляция (взаимная модуляция) возникает вследствие образования сигналов с комбинац. частотами при нелинейном преобразовании в УТ двух и более помех. Если эти составляющие в УТ далее усиливаются, создается побочный канал приёма. Количественно интермодуляция оценивается отношением уровня промодульн. сигнала на выходе УТ к уровню одного из взаимодействующих сигналов.

Перекрытые искажения проявляются в переносе модуляции с мешающего видеополосного сигнала на полезный. Блокирование выражается в уменьшении усиления полезного сигнала под действием мешающего сигнала близкой частоты и оценивается уровнем последнего, вызывающим ослабление на 3 дБ выходной мощности полезного сигнала. В режиме большого полезного сигнала наблюдается явление сжатия амплитуды, т. е. нарушения линейной зависимости между амплитудами сигнала на входе и выходе УТ. Повышение реальной избирательности достигается снижением с помощью фильтрующих цепей уровня помех на входе первого усилительного (нелинейного) элемента и принятием мер по линейризации его характеристик.

Верность воспроизведения сообщения — это способность Р. у. в отсутствие помех воспроизводить на выходе с заданной точностью закон модуляции принимаемых сигналов. Количественно оценивается искажениями, т. е. изменениями формы выходного сигнала по сравнению с модулирующей ф-цией. Лишние (амплитудные и фазовые) искажения, обусловленные нелинейными элементами УТ, не сопровождаются появлением в спектре сигнала новых составляющих, не зависят от уровня входного сигнала и глубины модуляции; амплитудные искажения проявляются в изменении соотношения амплитуд спектральных составляющих. Оценка фазовых искажений, проявляющихся в неравности сдвигов во времени разл. составляющих спектра сигнала при прохождении через УТ, проводится с использованием характеристики группового запаздывания. При слуховом приеме существенны лишь амплитудные искажения, при визуальном, особенно телевизионном, — также и фазовые. Для оценки линейных искажений при визуальном приеме пользуются, кроме того, т. н. переходной характеристикой Р. у., представляющей временную зависимость выходного напряжения при подаче сигнала с единичным скачком модулирующего напряжения.

Нелинейные искажения оцениваются коэф. гармонических искажений. Динамич. диапазон Р. у. определяется отношением макс. уровня сигнала, ограниченного допустимыми нелинейными искажениями в УТ, к чувствительности и характеризует пределы изменения уровня входных сигналов, в к-рых УТ практически линейен. С помощью автоматики, регулирующих усиления достигается динамич. диапазон 100—120 дБ.

Помехоустойчивость — способность Р. у. обеспечивать необходимое качество приема при действии разл. видов помех, разделяемых на мультипликативные, связанные со случайными изменениями свойств среды распространения эл.-магн. волн и приводящие к замираниям, искажениям формы сигнала, межсимвольной интерференции и т. п., и аддитивные, образующиеся в результате суммирования посторонних эл.-магн. колебаний с полезным сигналом. Последние делятся на естественные (атмосферные и космич. шумы, шумы теплового излучения Земли) и искусственные, в числе к-рых создаваемые сторонними радиопередатчиками, индустриальные и т. п. Помехи, не попадающие в осн. канал приема (внеканальные), ослабляются цепями, обеспечивающими частотную избирательность Р. у. Для подавления внутриканальных помех используется отличие их спектральных, временных и др. характеристик от характеристик сигнала, для чего применяют помехоустойчивые виды модуляции, корректирующие коды и спец. виды обработки сигналов. Для количеств. оценки помехоустойчивости используются вероятностный, энергетич. и артикулич. критерии. Под воздействием в помеху Р. у. понимают его реакцию на помехи, действующие как на антенну, так и на др. цепи — питания, управления и коммутации.

Существует неск. типов УТ, структурные схемы к-рых показаны на рис. 2. В Р. у. с п р я м ы м п р е о б р а з о в а н и е м с и г н а л а (рис. 2, а)

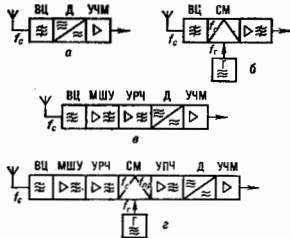


Рис. 2. Структурные схемы усилительно-преобразовательных трактов: а — с прямым преобразованием сигнала; б — с прямым преобразованием сигнала гетеродинированием; в — тракт прямого усиления; г — супергетеродин.

ными цепями (ВЧ) резонансного или фильтрового типа осуществляется частотная избирательность, а затем производится демодуляция сигнала (Д) и его последующее усиление на частоте модуляции (УЧМ). Простейшие устройства этого типа — детекторные были исторически первыми Р. у., их недостаток — низкая чувствительность, поэтому их применение ограничено СВЧ-системами анализа эл.-магн. обстановки и т. п. Применение более сложных демодуляторов, напр. автокорректирующего, позволяет реализовать простые и надёжные Р. у. сигналов относительной фазовой телеграфии с высокой помехоустойчивостью.

Разновидность Р. у. с прямым преобразованием сигнала — устройства с п р я м ы м г е т е р о д и н и р о в а н и е м с и г н а л а СВЧ на видеочастоте с помощью смесителя (СМ) и гетеродина (Г) (рис. 2, б). В этом случае осн. усиление и избирательность осуществляется на видеочастоте, а к преобразователю частоты (ПЧ) предъявляются повыш. требования к динамич. диапазону, коэф. шума, уровню интермодуляционных помех. Одноканальные Р. у. с независимым гетеродином используются, в частности, в доплеровских радиолокац. системах для измерения скорости объекта наблюдения. Квадратурные ПЧ позволяют осуществлять демодуляцию сигнала с любыми видами модуляции при сохранении информации об амплитуде и фазе исходного радиосигнала.

В Р. у. п р я м о г о у с и л е н и я (рис. 2, в) входная цепь осуществляет предварит. частотную избирательность и согласовывает антенну со входом малошумящего усилителя (МШУ), осн. назначение к-рого — повышение чувствительности устройства за счёт снижения уровня собств. шумов. Следующий затем усилитель радиочастоты (УРЧ) обеспечивает осн. усиление тракта и частотную фильтрацию сигнала от помех. Настройка на полезный сигнал производится синхронной перестройкой по частоте входной цепи, МШУ и УРЧ. Несмотря на использование афф. МШУ и сложных частотно-избирательных цепей, такие Р. у. из-за ряда трудностей техн. характера применяют лишь при сравнительно невысоких требованиях к чувствительности и избирательности.

В Р. у. прямого усиления функции МШУ и УРЧ могут выполняться разл. регенеративными усилителями: квантовыми парамагнитными — мазерами, параметрическими, на туннельных диодах, Ганна диодах и др., в к-рых в колебательную систему в сигнальном тракте вносится обусловленное разл. фаз. явлениями отрицательное дифференциальное сопротивление, обеспечивающее усиление по мощности за счёт перекачки энергии от источника питания (накачки). Регенеративные усилители могут обладать весьма малыми коэф. шума и значительным усилением по мощности, что позволяет

обойтись одним каскадом УРЧ, однако они относительно узкополосны и требуют повыш. внимания к вопросам обеспечения устойчивости по отношению к дестабилизирующим факторам. В супергенераторе входное в колебательную систему отрицат. сопротивление таково, что в течение части периода в ней самовозбуждаются автоколебания. Р. у. с супергенераторами в качестве УРЧ свойственны значит. искажения сигнала и опасность паразитного излучения через приёмную антенну, вследствие чего их применение ограничено портативными устройствами СВЧ, отечающими сравнительно невысоким требованиям.

Осн. тип построения УТ разл. классов Р. у. — супергетеродина (рис. 2, з) с одно- или многократным преобразованием частоты. Входная цепь, МШУ и УРЧ образуют т. н. преселектор, обеспечивающий чувствительность и предварт. частотную избирательность Р. у. В результате одноврем. воздействия усиленного сигнала и колебаний гетеродина на смеситель, содержащий нелинейный элемент или элемент с переменным параметром, на выходе образуются колебания с гармониками и комбинационными составляющими с частотами $f = |n f_c \pm m f_s|$; $n, m = 0, 1, 2, \dots$ Одна из этих составляющих выделяется фильтром и используется в качестве новой несущей выходного сигнала с частотой, называемой промежуточной $f_{пр}$. Обычно $f_{пр} = |f_c - f_s|$, $f_s \approx f_c$ (равностороннее преобразование); при этом f_c выбирается так, чтобы $f_{пр}$ была ниже границ диапазона рабочих частот Р. у. Реже используются преобразования при $n = 2, 3, \dots$ и суммарное преобразование $f_{пр} = |f_c + f_s|$. В процессе преобразования происходит перенос спектра сигнала в область $f_{пр}$ без нарушения амплитудных и фазовых соотношений его составляющих, т. е. ПЧ линейен по сигналу. За ПЧ следует усилитель промежуточной частоты (УПЧ), частотно-избирательные цепи к-рого обеспечивают осн. избирательность супергетеродина по соседнему каналу. Для обеспечения $f_{пр} = \text{const}$ при перестройке Р. у. в рабочем диапазоне частот реализуется сопряжённая настройка входной цепи, избирательных цепей УРЧ (МШУ) и гетеродина. Перенос сигнала на более низкую фиксированную частоту позволяет сравнительно просто реализовать в УПЧ достаточно устойчивое усиление, обеспечить высокую частотную избирательность, а также оптимальную фильтрацию сигнала от помех с помощью согласованных фильтров, однако вызывает и такие нежелат. эффекты, как образование побочных каналов приёма (зеркального, интермодуляционного, комбинационного и др.), влияние неустойчивости частоты гетеродина на настройку, возможность излучения колебаний гетеродина через приёмную антенну. Такая возможность набл. реально при отсутствии УРЧ (МШУ), когда первым каскадом УТ является ПЧ, как это зачастую имеет место в Р. у. миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Весьма высокие требования к избирательности по соседнему и зеркальному каналам выполняются в супергетеродинах с последовательным многократным преобразованием частоты.

Чувствительность Р. у., особенно в СВЧ-диапазоне, ретационн образом зависит от коэф. шума и усиления по мощности первых каскадов УТ. На рис. 3 приведены обобщённые шумовые характеристики МШУ и дюдных смесителей. Наименьшим уровнем шумов обладают охлаждаемые квантовые парамагн. усилители, однако вследствие высокой сложности и стоимости, плохих массогабаритных показателей их использование ограничено практически радиостроительными Р. у. Весьма низким уровнем шумов обладают также охлаждаемые параметрич. усилители и усилители на *лампех транзисторах* с барьером Шоттки (УПТШ), причём массогабаритные показатели допускают их применение даже в бортовых Р. у. Оба типа устройств применяются преим. в наземных Р. у. систем космич. связи, причём вследствие большей простоты и технологичности полупроводниковые они постепенно вытесняют параметрич. усилители. Неохлаждаемые параметрич. усилители и УПТШ широко используются в бортовых Р. у. космич. систем, а УПТШ также и в Р. у. наземных радиорелейных линий разл. типов, в радиолокац. и др. системах на частотах выше 4—6 ГГц. На более низких частотах МШУ и УРЧ реализуются преим. на *транзисторах биполярных*. Лампы *бегущей волны* вытесняются полупроводниковыми приборами во всех частотных диапазонах, включая СВЧ. На миллиметровых и субмиллиметровых волнах первым каскадом Р. у. служит чаще всего ПЧ с балансным смесителем на диодах с барьером Шоттки, причём широко используется схема с возвращенным энергич. комбинац. частот.

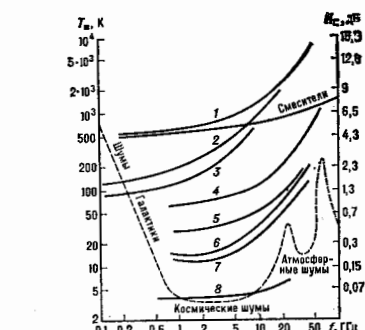


Рис. 3. Зависимость шумовых параметров МШУ и дюдных смесителей от частоты [4]: 1 — лампа бегущей волны; 2 — усилитель на туннельном диоде; 3 — усилитель на биполярном транзисторе; 4 — УПТШ; 5 — полупроводниковый ПУ; 6 — УПТШ, охлаждаемый до 20 К; 7 — полупроводниковый ПУ, охлаждаемый до 20 К; 8 — квантовый парамагнитный усилитель, охлаждаемый до 4 К.

роч. усилители. Неохлаждаемые параметрич. усилители и УПТШ широко используются в бортовых Р. у. космич. систем, а УПТШ также и в Р. у. наземных радиорелейных линий разл. типов, в радиолокац. и др. системах на частотах выше 4—6 ГГц. На более низких частотах МШУ и УРЧ реализуются преим. на *транзисторах биполярных*. Лампы *бегущей волны* вытесняются полупроводниковыми приборами во всех частотных диапазонах, включая СВЧ. На миллиметровых и субмиллиметровых волнах первым каскадом Р. у. служит чаще всего ПЧ с балансным смесителем на диодах с барьером Шоттки, причём широко используется схема с возвращенным энергич. комбинац. частот.

В качестве источников гетеродиных колебаний применяются обычно маломощные генераторы на разл. активных элементах (транзисторах, ИС, диодах Ганна, к्लитронах и др.) с относит. частотной неустойчивостью $10^{-2} - 10^{-4}$, достигаемой использованием разнообразных типов резонаторов: резонансных контуров с сосредоточенными и распределёнными параметрами, кварцевых, диэлектрич., на поверхностных акустич. волнах и т. п. Используются термостабирирование генераторов и перенос высокостабильных колебаний в СВЧ-диапазон с помощью транзисторно-варакторных цепочек. Широко применяются декадные синтестаторы частот с дискретным частотным интервалом, построенные на основе систем фазовой автоподстройки частоты с переменным делителем частоты, а также по методу суммирования импульсных последовательностей.

В интегральной технике решается широкий круг задач обработки сигнала, подразделяемых на группы, для каждой из к-рых может быть синтезирована типовая оптимальная структура тракта. Структурный синтез оптимального Р. у. разработан в осн. для случая воздействия аддитивных широкополосных шумовых помех гауссового или марковского типа, что характерно, в частности, для диапазонов метровых, дециметровых и сантиметровых волн в отсутствие искусства помех. Первая группа задач — оценка (фильтрация) непрерывного сообщения, существенно изменяющегося на интервале наблюдения. При приёме модулированных колебаний процесс фильтрации сообщения эквивалентен процессу демодуляции. Этот круг задач решается с использованием оптимальных линейных фильтров, сложных частотных и фазовых демодуляторов. Вторая

группа — приём дискретных сообщений — включает бинарное обнаружение (приём двучастных сигналов с пассивной паузой) в импульсных и цифровых РТС, обнаружение сигнала в радиолокации, распознавание двух сигналов, обнаружение и распознавание неск. сигналов. Применяются оптимальные фильтры, как согласованные с сигналом, так и нечувствительные к его фазе, коррелторы, фазовые обнаружители, устройства синхронизации и др. Третья группа задач связана с оценкой разл. параметров принимаемых сигналов в радиолокации, что на интервале наблюдения соответствующий параметр не изменяется. Это осн. задачи Р. у. РТС измерит. типа — радиолокационных, радионавигационных, радиотелеметрических, в них широко применяются сложные сигналы (шумоподобные, с линейной частотой модуляции и др.).

В устройствах управления и отображения используются электронные исполнительные элементы (*варикапы, pin-диоды, полевые транзисторы*), управляемые, в зависимости от функционального и цифрового назначения Р. у., в аналоговой форме, с помощью непрограммируемых и программируемых цифровых устройств, микропроцессоры и перепрограммируемых постоянных устройств памяти, причём существует тенденция к вытеснению аналоговых устройств цифровыми (см. также *Памяти устройств*). Индикация одномерных величин (частоты настройки, уровня сигнала и т. и.) производится на цифровых, знаковых или линейных светодиодных индикаторах, двумерная индикация осуществляется на осциллографических, мозаичных светодиодных индикаторах, дисплеях на жидких кристаллах и др.

Оси. направления развития Р. у.: широкое внедрение цифровых методов оптимальной обработки сигналов и цифровых устройств управления и отображения; более эффективное использование СВЧ-диапазона, освоение миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов; комплексная микроинтеграция с повышением степени интеграции, внедрением СВЧ- и сверхкоротных ИС.

Лит.: Радиоприёмные устройства, под ред. Л. Г. Варулина, М., 1984; Головин О. В. Профессиональные радиоприёмные устройства дециметрового диапазона, М., 1985; Конюхович Д. М., Современный радиоприёмный приёмник, М., 1986; Твёрдые тела: устройства СВЧ в технике связи, М., 1988; Радиоприёмные устройства, под ред. А. П. Жукоского, М., 1989; Розанов Б. А., Розанов С. В., Применение миллиметровых волн, М., 1989. *Н. Н. Фокин.*

РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ — раздел физики, в котором изучаются спектры поглощения разл. веществ в диапазоне радиоволн (на частотах эл.-магн. поля от 10^8 до $6 \cdot 10^{11}$ Гц). В более широком смысле к Р. относят также исследования резонансной дисперсии, релаксации, нелинейных явлений, индукторов, испускания и др. явлений резонансного взаимодействия эл.-магн. и акустич. полей указанного диапазона с квантовыми системами.

Резонансное поглощение в диапазоне радиоволн обусловлено индукторами, переходами между уровнями энергии E_i атомов, молекул, атомных ядер и пр., удовлетворяющими условию

$$\Delta E = E_i - E_j = h\nu, \quad (1)$$

где ν — частота радиоволны. Такие интервалы энергии возникают, напр., при взаимодействии магн. моментов электронов и ядер с внеш. магн. полем [см. *Земана эффект*, *Электронный парамагнитный резонанс* (ЭПР), *Ядерный магнитный резонанс* (ЯМР)]; электрич. квадрупольных моментов ядер с градиентом внутр. кристаллич. поля [см. *Ядерный квадрупольный резонанс* (ЯКР)]; при взаимодействии магн. моментов электронов с ядром (сверхтонкое расщепление уровней энергии); во вращательных спектрах молекул в газах (см. *Микроволновая спектроскопия*); при туннелировании атомов, ионов и молекулярных фрагментов в кристаллах и стёклах; при коллективном взаимодействии электронов в магнитоупорядоченных веществах (см.

Ферромагнитный резонанс, *Антиферромагнитный резонанс*); при движении электронов проводимости в магн. поле (см. *Циклотронный резонанс*) и пр. Интервалы ΔE между уровнями энергии, изучаемые в Р., обычно соответствуют диапазону СВЧ (10^8 — $3 \cdot 10^{11}$ Гц), а в случае ЯМР и ЯКР — диапазону ВЧ (10^7 — $3 \cdot 10^9$ Гц). Столь малые интервалы, как правило, не удаётся разрешить в оптич. и ИК-спектрах, их можно зарегистрировать только методами Р.

По сравнению с оптич. спектроскопией и инфракрасной спектроскопией Р. имеет ряд особенностей. В Р. практически отсутствует аппаратурное уширение спектральных линий, поскольку в качестве источника радиоволн используются когерентные генераторы, а частоту можно измерить с высокой точностью. Отсутствует и типичное для оптич. диапазона радиационное уширение, т. е. вероятность спонтанного испускания, пропорциональная ν^3 , в диапазоне радиоволн пренебрежимо мала. Из-за малой энергии $h\nu$ на единицу мощности приходится большое число квантов, что практически устраняет квантовомехан. неопределённость фаз радиочастотного поля, к-рое можно описывать классически. Всё это позволяет получать информацию о веществе на точных измерений физич. резонансных линий, к-рая определяется в Р. взаимодействием микрочастиц друг с другом, с тепловыми колебаниями матрицы и др. полями, а также их движением (в частности, *Доллера эффект* в газах). Ширина линий в Р. меняется в очень широких пределах: от ~ 1 Гц для ЯМР в жидкостях до $\sim 10^8$ Гц для ЭПР в концентраторах парамагнетиков, ферромагн. резонанса, *парапетрического резонанса* ионов в твёрдых телах.

С др. стороны, из-за малой величины ΔE уменьшается чувствительность методов Р. Итенсивность регистрируемых спектров определяется преобладанием поглощения эл.-магн. энергии над эл. индукторов, испусканием, т. е. равностью населённости $N_j - N_i$ уровней энергии, между к-рыми происходит переходы. В условиях теплового равновесия при темп-ре T эти населённости подчиняются *Больцмана распределению*, откуда для невырожденных уровней

$$\Delta N = N_j - N_i = (N_i + N_j) \text{th}(\Delta E / 2kT). \quad (2)$$

В оптич. спектроскопии, как правило, $\Delta E \gg kT$ (за исключением практически только ниж. уровней); в Р., напротив, вплоть до $T \sim 1$ К выполняется неравенство $\Delta E < kT$, поэтому величина ΔN мала и обратно пропорциональна темп-ре.

Для получения спектров последнему веществу помещают в объёмный резонатор, волновод или ВЧ-контур и в зависимости от типа резонансных переходов (магн. или электрич.) подвергают действию соответствующей компоненты эл.-магн. поля. Магн. дипольные переходы характерны для всех видов *магнитного резонанса* (ЭПР, ЯМР, ЯКР и т. д.), электрич. переходы — для микроволновых спектров газов, параэлектрич. резонанса и др. Эксперим. методы регистрации спектров в Р. можно разделить на стационарные, импульсные и косвенные.

В стационарных методах образец непрерывно облучают достаточно слабым (не вызывающим когерентных эффектов) эл.-магн. полем, частоту к-рого медленно изменяют. При выполнении условия (1) часть энергии поля поглощается веществом, что регистрируют по соответствующему уменьшению амплитуды эл.-магн. колебаний. Зависимость коэф. поглощения от частоты ν и представляет собой стационарный спектр поглощения. Вместо изменения частоты в Р. часто применяют эквивалентное изменение внеш. магн. или эл. поля, влияющего на условие резонанса (1).

Мощность Р эл.-магн. поля, поглощаемая веществом на частоте ν , равна

$$P = h\nu \Delta N g(\nu) |W_{ij}|^2, \quad (3)$$

где $\Delta\nu$ определяется ф-лой (2), $g(\nu)$ — плотность состояний на частоте перехода, определяющая форму и ширину линии поглощения, а величина W_{ij} пропорциональна недиагональному матричному элементу оператора магн. (электрич.) дипольного момента частицы и амплитуде соответствующей компоненты радиочастотного поля.

Стационарное поглощение веществом мощности P предполагает дальнейшую передачу энергии термостату, роль к-рого обычно выполняют степени свободы, связанные с тепловым движением (колебания кристаллич. решётки, хаотич. движение молекул жидкости, кинетич. энергия электронов проводимости и пр.). Указанный процесс называют продольной релаксацией и характеризуют постоянной времени τ_1 . При росте мощности эл.-магн. поля до значений, обеспечивающих условие $g(\nu)|W_{ij}|^2 \tau_1 \approx 1$, продольная релаксация уже не успевает отвести в термостат поступающую энергию, происходит насыщение резонансного поглощения ($\Delta N \rightarrow 0$). Насыщение используют в Р. для измерения τ_1 и получения информации о движении частиц, спин-фоновых взаимодействиях и пр.

Импульсные методы получили распространение в ЯМР, ЯНР и отчасти в ЭНР. При этом вещество подвергается действию короткого мощного радиочастотного импульса, переводящего систему частиц в когерентное нестационарное квантовое состояние, являющееся суперпозицией состояний $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$. Возникающее при этом движение ансамбля частиц (в случае магн. резонанса — когерентная прецессия спинов вокруг постоянного магн. поля) генерирует в датчике сигнал свободной индукции $F(t)$. Взаимодействие частиц друг с другом и с разл. полями приводит к потере когерентности и затуханию $F(t)$ с характерным временем поперечной релаксации τ_2 . Ф-ция $F(t)$ содержит полную информацию о спектре поглощения и связана с ним преобразованием Фурье. Применение двух и более последоват. импульсов позволяет частично компенсировать потерю когерентности (см. *Спиновые эхо*), что повышает чувствительность и расширяющую способность метода.

В косвенных методах резонансное поглощение радиочастотного поля регистрируют по изменению (обычно небольшому) нек-рых макроскопич. характеристик вещества. Ими могут быть, напр., интенсивность и поляризация оптич. люминесценции (оптич. детектирование), аннотропия γ - и β -радиоакт. излучения, траектория молекулярных и атомных пучков в водорододом веш. поле (см. также *Раби метод*), темп-ра образца, его способность к нек-рым хим. реакциям и пр. К косвенным методам можно отнести также двойные резонансы, в к-рых поглощение квантов одной частоты регистрируют по отклику на другой частоте. Для расширения возможностей Р. используют многоквантовые и параметрич. эффекты, акустич. методы (см., напр., *Акустический парамагнитный резонанс*). В ВЧ-области диапазона радиоволн (частота выше 10^4 Гц) Р. по своим методам и объектам исследования приближается к ИК-спектроскопии (см. *Субмиллиметровая спектроскопия*).

Р. применяют в физике, химии, биологии, технике для получения детальной информации о внутр. структуре и атомно-молекулярной динамике твёрдых тел, жидкостей и газов, определения структуры и конформации молекул, измерения магн. и электрич. моментов микро-частиц, изучения их взаимодействий друг с другом и с разл. внеш. и внутр. полями. Методы Р. используют также для качеств. и количеств. хим. анализа, контроля хим. и биохим. реакций, определения структуры примесей и дефектов, измерения магн. полей, темп-ры, давления, для неразрушающего контроля материалов и изделий. В Р. было впервые получено индуцирующее излучение, что привело к созданию *квантовых генераторов* и усилителей СВЧ-диапазона — *квантовых стандартных частот* и чувствительных приёмников, а затем и

лазеров (см. также *Квантовая электроника*). Один из видов двойного резонанса — динамич. поляризацию ядер (см. *Ориентированные ядра, Оверхаузера эффект*) — применяют при создании поляризованных ядерных мишеней. Р. используют также в медицине для получения диагностич. изображений внутр. органов (см. *Томография*).

Лит.: Тауэр Ч., Шаффер А., Радиоспектроскопия, пер. с англ., М., 1958; Ибрагим Д., Спектроскопия в высших и сверхвысоких частотах, пер. с англ., М., 1958; Альтшулер С. А., Козырев В. М., Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп, 2 изд., М., 1972; Абрагам А., Лернер магнетизм, пер. с англ., М., 1963; Сянткер Ч., Основы теории магнитного резонанса, пер. с англ., 2 изд., М., 1981; Γιυνди А. Г., Феден Э. И., Идентичный магнитный резонанс. Основы и приложения, Новосибирск, 1980; Физические основы квантовой радиофизики, т. 1, 1980, В. А. Азарчук.

РАДИОТЕЛЕКОП — устройство для приёма радиополучения космич. объектов. Состоит из трёх осн. частей: антенны, маломощного приёмника (*радиометра*) и анализатора сигналов.

Антенна радиотелескопа собирает падающее на неё радиозлучение с опред. участка неба, угл. размеры к-рого определяются шириной диаграммы направленности. Эффективность антенны зависит от еёэф. площади и шумовой температуры. Антенна находится в поле излучения Земли, к-рое соответствует шумовой темп-ре ок. 300 К. Чтобы избежать «засветки» излучением Земли, принимаются спец. меры. Используют т. н. скалярные (коррелируемые) облучатели антенн. Такой облучатель представляет собой кончик рупор с тарелочной поверхностью. Он обеспечивает максимально возможный приём сигнала со всей геом. поверхности зеркала антенны и минимально возможный вне его. Шумовая темп-ра антенны достигает мин. значений при использовании Кассегреновской (или Грегорианской) системы облучения (аналогичной соответствующим схемам оптич. телескопов) в сочетании со скалярным облучателем во вторичном фокусе. В такой системе облучаемое вторичное зеркало находится на фоне неба, что уменьшает «засветку» излучением Земли. Яростная температура неба в диапазоне сантиметровых и миллиметровых радиоволн составляет всего неск. градусов. Чтобы снизить потери, определяемые поглощением в атмосфере, Р. миллиметрового диапазона устанавливают высоко в горах.

Приёмник Р. имеет низкий уровень шумов. Для обеспечения минимальности шумовой темп-ры системы антенна — приёмник охлаждается не только усилителем, но и облучателем или его входная часть до 15–20 К. Шумовая темп-ра маломощных транзисторных усилителей ~ 1–20 К и примерно равна частоте, выраженной в Гц. На волнах миллиметрового диапазона применяются также *квантовые усилители* и *параметрические усилители*. После усиления сигнал обычно поступает на смеситель, где смешивается с сигналом гетеродина, а далее на анализатор. Это может быть просто квадратичный детектор, на выходе к-рого сигнал пропорционален измеряемой мощности (темп-ре), анализатор импульсного излучения пульсаров, спектроанализатор, система записи на широкополосный магнитфон (в случае наблюдений в режиме радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами). Результаты наблюдений обрабатываются на ЭВМ.

Для снижения разл. «паразитных» эффектов при измерении слабых сигналов от космич. объектов применяют ряд методов. Расчётная чувствительность измерений шумового сигнала $\delta T = T_e \sqrt{\Delta f \tau}$ определяется радиометрич. выигрышем, равным $\sqrt{\Delta f \tau}$; в случае широких полос пропускания $\Delta f \sim 1$ ГГц и времени накопления сигнала $\tau \sim 10^8$ с ($(\Delta f \tau)^{1/2} \sim 10^4$), $\delta T \approx 20$ мкК (при $T_e \approx 20$ К). Чтобы выделить сигнал такого малого уровня, необходимо компенсировать (вычест.) собств. шум аппаратуры и фона, напр. при помощи источника пост. тока. Это простейший случай — компенсация метода. Однако реальная техн. чувствительность определяется стабильностью коэф. усиления аппаратуры, флук-

туациями в атмосфере и т. д. Снижение влияния этих факторов достигается методами амплитудной, диаграммой, частотной модуляции; нулевым, корреляционным. В методе амплитудной модуляции сигнал непосредственно на входе приёмника происходит быстрое сравнение измеряемой величины (сигнал объекта) с сигналом эталона (эквивалента) и выделения разностного сигнала на выходе приёмника. Если эталонный сигнал близок к измеряемой величине, то изменения уровня собств. шумов аппаратуры практически не влияют на измеряемую величину. Чувствительность этого метода $\Delta T = T_{\text{эл.}} / \sqrt{2 \Delta f}$. Практически полное исключение влияния изменения коэф. усиления радиометра достигается в нулевом методе — тем-ра эквивалента непрерывно подстраивается системой обратной связи под исследуемому тем-ру так, чтобы сигнал на выходе равнялся нулю. Измеряемой величиной в этом случае является тем-ра шумов эквивалента. В качестве эквивалента может быть выбрана близлежащая площадка неба, т. е. антенна попеременно наводится то на источник, то на площадку рядом с ним — диаграмма в а м п л и т у д н ы й. При этом практически исключается влияние атмосферы. Диаграммная модуляция может осуществляться путём качания вторичного зеркала в системе Кассегрена, переключением выходов двух облучателей (расположенных в фокальной плоскости зеркальной антенны) либо переключением фазы сигнала в радиointерферометре. В случае спектральных исследований переключение может осуществляться по частоте, т. е. сравниваться с шумами вне спектральной линии, — ч а с т о т а я м о д у л я ц и я. В поларизац. и радиointерференц. измерениях часто применяются корреляц. приём сигналов — двухканальный приёмник выделяет коррелированную составляющую сигнала. Собств. шумы аппаратуры в таком приёмнике не коррелируют между собой, в то время как принимаемый сигнал от точечного источника будет когерентным, т. е. будет коррелировать на выходе радиометра. Аналогичное явление происходит при приёме поларизов. сигнала источника на два ортогональных облучателя.

Лит. см. при ст. *Антенна радиотелескопа. Апертурный синтез.* Л. И. Матвеев.

РАДИОФИЗИКА — раздел физики, охватывающий изучение и применение эл.-магн. колебаний и волн радиодиапазона, а также распространение развитых при этом методов в др. науки. На шкале эл.-магн. волн радиодиапазон занимает интервал частот от 10^4 до 10^{11} Гц (см. *Радиоволны*), и первоначально радиофиз. исследования придерживались этих границ. Со временем, однако, проявилась тенденция к «экспансии», и ныне Р. вобрала в себя физику эл.-магн. колебаний практически любого диапазона частот.

Совр. Р. имеет сложную и разветвленную структуру, обеспечивающую: 1) тех. освоение всего охватываемого спектра эл.-магн. колебаний; 2) исследования физ. свойств линейных и нелинейных систем (сред) и создание их адекватных моделей; 3) обогащение новыми физ. идеями радиотехники, технологии и др. инженерных областей; 4) развитие методов метрологии в части измерения важнейших физ. параметров, констант и создание надёжных эталонных стандартов; 5) исследование свойств окружающего пространства; 6) изучение эл.-магн. проявлений биол. объектов.

Р. сформировалась в 30–40-е гг. 20 в. с развитием радиотехники, радиосвязи, радио- и телерадиотехники, радионавигации и радиолокации, что потребовало освоения новых диапазонов частот, разработки и воплощения физ. принципов генерации, излучения, распространения и приёма радиоволн, модуляции и кодирования радиосигналов и т. д. В СССР развитие Р. связано с именами Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси и с созданной ими науч. школой.

Первоначально развитие Р. определялось тремя компонентами: теорией колебаний и волн, физ. электро-

ники и электродинамикой. Причём Р. не только использовала достижения в этих областях науки, но и способствовала их развитию.

Теория колебаний и волн содержит матем. аппарат для исследования процессов в колебл. системах (линейных и нелинейных, с сосредоточенными и распределёнными параметрами, постоянными или периодически меняющимися во времени, см. *Коллебания*). Особую роль играют исследования нелинейных колебаний (в частности, автоколебаний), лежащих в основе работы большинства генераторов электромагнитных колебаний радиодиапазона. Впоследствии в этот раздел вошли теоретич. и эксперим. задачи, в к-рых колебл. движения являются частными (хотя и по-прежнему выделенными) случаями общих процессов. Сформировалось особое направление исследования динамич. поведения нелинейных систем, отвлечённое от их конкретной реализации с привлечением методов качественной теории дифференц. ур-ний, физического (аналогового) и численного моделирования. В Р. активно используется это новое направление, к-рое чаще наз. *нелинейной динамикой* (см. *Динамическая система, Нелинейные уравнения математической физики*).

В физ. электронике Р. стимулировала оптимизацию характеристик уже существовавших приборов и создание принципиально новых эл.-вакуумных, газоразрядных и твердотельных устройств. Быстродействие, простота управления, высокие значения кпд, перекрытие всех диапазонов частот и мощностей, высокая чувствительность, избирательность, шероховатые, низкий уровень шумов и др. требования, предъявляемые к разл. устройствам, могут быть удовлетворены только с привлечением разнообразных физ. явлений. Поэтому радиофиз. исследования сопутствовали, а иногда предшествовали исследованиям электронной и ионной эмиссии, полупроводниковой плазмы и разработка методов управления движением заряд. частиц (см. *Электронная и ионная оптика, Ускорители заряженных частиц*), изучение взаимодействия эл.-магн. полей с электронными потоками, с газоразрядной плазмой и с плазмой твёрдых тел и др. В результате развития представлений об автофазировке и группировке электронов, о самосогласованном синхронном взаимодействии частиц с эл.-магн. полем появились такие приборы, как клистрон, магнетрон, лампа бегущей волны, лампа обратной волны и др., а затем мазер на циклотронном резонансе, гиротрон, лазер на свободных электронах и т. п., к-рые являются и предметом изучения Р., и базой для радиофиз. исследований (см. *Релятивистская электроника*).

Электродинамика, в осн. опирающаяся на ур-ния Максвелла в линейных средах, обеспечила понимание процессов излучения, распространения и приёма радиоволн. Это позволило создать разл. элементы радиоаппаратуры как в ДВ-диапазонах (системы с сосредоточ. параметрами — колебл. контуры, фильтры, преобразователи и т. п.), так и в КВ-диапазонах (системы с распределёнными параметрами — линии передачи, волноводы, объёмные резонаторы, аттенуаторы и т. п.). Осн. направления исследования: излучение и распространение радиоволн в разл. средах (напр., в космич. плазме), с учётом аннотирования, поглощения, рефракции и дифракции, рассеяния, отражения и нелинейных эффектов, связанных со взаимодействием излучения с веществом, создание ми. типов антенн.

По мере развития Р. её методы проникали в др. области физики. В результате в Р. стали различать «физику для радио» и «радио для физики». Новые задачи, новые цели, а также освоение новых диапазонов частот привлекли в Р. идеи и методы из др. областей физики, в частности из оптики (приёмы управления волновыми пучками, принципы действия таких элементов, как линзы, зеркала, интерферометры, поляриды и т. п.), что привело к появлению нового раздела Р. — *квантовой оптики* (теория оптич. пучков с учётом поперечной диффузии

комплексных амплитуд, квазиоптика. линии передачи, открытые резонаторы и т. п.). С др. стороны, радиодифф. методы, развитые, напр., для сантиметрового диапазона длин волн, проникнув в оптику, заметно расширили её возможности, вызвав к жизни такие разделы, как *волоконная оптика*, *интегральная оптика*, *волноводы*. Поэтому иногда используют такие гибридные понятия, как «радиоптика», «оптоэлектроника». Затем мн. приёмы были перенесены и в др. разделы науки, прежде всего в акустику (напр., «акустоэлектроника»).

В результате взаимодействия с др. областями физики и observations от. разделов внутри Р. образовался ряд самостоят. направлений. Статистич. Р. охватывает такие вопросы, как флуктуат. процессы в колебат. и автоколебат. системах, управление формой и стабильностью спектральных линий генераторов, шуми прымьков и преобразователей, неравновесное излучение сред, распространение волн в средах со случайными неоднородностями. разработка и применение методов корреляц. анализа сигналов, предельные возможности получения голограмм, изображений и др. проблемы. *Радиоспектроскопия* — совокупность методов, разработанных для измерения и расшифровки спектров излучения и поглощения атомов, молекул и кластеров, попадающих в интервал частот радиодиапазона, развития новых принципов диагностики и анализа сред. *Радиоастрономия* — разработка физ. методов приёма, обработки и интерпретации слабых сигналов, приходящих от космоса, источников, создание антенн и интерферометров с узкой диаграммой направленности, исследование притоков радиополучения разл. источников. Изучение взаимодействия излучения с веществом на квантовом уровне, к-рое привело к созданию квантовых генераторов и усилителей для сверхкоротковолновых участков радиодиапазона, вызвало появление *квантовой электроники*. Иногда выделяют более общее направление — *квантовую Р.*, к-рая обеспечивает новый теоретич. подход, охватывающий на сочетание классич. электродинамики (для описания излучения) и квантовой механики (для описания вещества). Сюда примыкает *микроволновая электроника*, существенно изменившая адекватно и технич. вооружение радиотехники (полупроводниковые приборы, интегральные схемы, криогенная электроника, высокотемпературная сверхпроводящая электроника, жидкие кристаллы и т. п.).

Т. о., круг рассматриваемых Р. вопросов и сфера её влияния непрерывно расширяются. Однако Р. остаётся традиционно самостоят. областью знаний и методов исследования, так или иначе связанных с использованием эл.-магн. излучения.

А. В. Галюнов-Грехов, М. А. Миллер.

РАДИОХИМИЯ — раздел химии, охватывающий исследование хим. свойств радиоакт. элементов и их соединений, когда использование обычных хим. методов невозможно или затруднено. Это — исследование короткоживущих радионуклидов, высокоактивных веществ, *трансурановых элементов*. К Р. относят также проблемы получения ядерного горючего для ядерных реакторов, переработки радиоакт. отходов для подготовки их к захоронению и др.

РАДИОИОХ (радиоотклик) — радиосигнал, отражённый от одного или группы предметов или от области пространства, заполненной средой, способной рассеивать радиоволны, и принятый в том же пункте, где расположено радиопередатющее устройство. Отражающими объектами служат как скопления насекомых, птиц и др., так и воздушные слоистые образования, а также вызванные *турбулентностью* среды неоднородности *атмосферы*. Анализ Р. входит в задачи *радиолокации* — определение расстояний до отражателя, его свойств, движений и изменений. Широкое развитие получили методы анализа Р. в физике атмосферы, геофизике и в метеорологии.

РАДИУС ИНЕРЦИИ — величина r , имеющая размерность длины, с помощью к-рой момент инерции тела от-

ноительно данной оси выражается ф-лой $I = Mr$, где M — масса тела. Напр., для однородного шара радиуса R относительно оси, проходящей через его центр, $I = 0,4 MR^2$, $\rho = \sqrt{0,4 R} \approx 0,632 R$.

РАДИУС ЯДРА — среднее к-вадратич. — величина, характеризующая размеры ядра и определяемая соотношением

$$R = \sqrt{\int r^2 \rho(r) dr^3 / \int \rho(r) dr^3}.$$

Здесь r — расстояние до центра ядра, ρ — плотность нуклонов в ядре (см. *Ядро атома*). В ядерной физике часто рассматривают также по отдельности Р. я. для нейтронов R_n (когда ρ_n — плотность нейтронов), для протонов R_p (ρ_p — плотность протонов) и зарядовый радиус $R_{зар}$ ($\rho_{зар}$ — зарядовая плотность ядра). Предельные 2 величины связаны соотношением

$$R_{зар} = \sqrt{R_p^2 + r_p^2},$$

где r_p — среднеквадратичный зарядовый радиус *протона*. **РАДОН** (Radon), Rn, — радиоактивный хим. элемент VIII гр. периодич. системы элементов, ат. номер 86, инертный газ. Все изотопы Р. высокоактивны; α -радиоактивные ^{222}Rn (собственно Р., $T_{1/2} = 3,824$ сут.), ^{220}Rn (имеет назв. *торон*, Tn, $T_{1/2} = 55,6$ с) и ^{219}Rn (а к т и о в, An, $T_{1/2} = 4,0$ с) входят в состав естеств. радиоакт. рядов и в некоторых кол-вах постоянно присутствуют в земной коре; ср. концентрация Р. в атмосфере $6 \cdot 10^{-17}$ массовых %; изотопы ^{222}Rn , ^{220}Rn и ^{219}Rn часто наз. *эманациями*. Искусственно получены изотопы ^{211}Rn — ^{214}Rn , из них наиб. устойчив ^{211}Rn (электронный захват, β^+ - и α -распад, $T_{1/2} = 14,6$ ч). Электронная конфигурация внеш. оболочек $6s^2 p^6$. Энергия последоват. ионизации 10,745, 21,4 и 29,4 эВ соответственно. Радиус атома Rn 0,22 нм.

При нормальных условиях плотность Р. 9,73 кг/м³, $t_{кип} = -81,9$ °C, $t_{пл} = -71$ °C, критич. тем-ра 104,5 °C при критич. давлении 6,2 МПа, тройная точка соответствует —73 °C и давлению 0,07 МПа. Уд. тепло испарения 77,9 кДж/(кг·K), теплоёмкость $c_p = 90$ Дж/(кг·K) (при 298 K и нормальном давлении). Растворимость Р. в 100 г воды 51,0 мл (0 °C) и 13,0 мл (50 °C).

Химически инертен, непосредственно реагирует только с F₂. С нек-рыми соединениями образует клатраты. Радонные ванны применяются для лечения нек-рых заболеваний. По присутствию Р. в воздухе судят о наличии U и Th в приповерхностных слоях земной коры. На определение скорости выделения Р. из твёрдого тела при разл. тем-рах основан эманационный метод исследования твёрдых тел. Существует предположение, что присутствие в воздухе Р. способствует возникновению нек-рых онкологич. заболеваний.

С. С. Вербицкий.

РАДОНА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ — интегральное преобразование Ф-ции $f(x)$ от n вещественных переменных, $x = (x_1, \dots, x_n)$, ставящее в соответствие Ф-ции $f(x)$ её интеграл по $(n-1)$ -мерной плоскости (гиперплоскости) $\Pi = \{x = C\}$ (хотя бы один из вещественных параметров ξ_i , задающих положение Π в \mathbb{R}^n , не равен 0):

$$F(\xi, C) = \int \delta(x - C) f(x) dx = \int_{\Pi} f(x) dV_{n-1},$$

где dV_{n-1} — евклидов элемент объёма на Π .

Р. п. $F(\xi, C)$ Ф-ции $f(x)$ — однородная Ф-ция своих переменных степени -1 , связанная с Фурье преобразованием $\tilde{f}(\xi)$ Ф-ции $f(x)$ Ф-лой

$$F(\xi, C) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} d\alpha \tilde{f}(\alpha \xi) \exp(-i\alpha C).$$

Ф-лы обращения Р. п. различны для чётных и нечётных n : для чётных n

$$f(x) = \frac{(-1)^{n/2}(n-1)!}{(2\pi)^n} \int_{\Gamma} d\Omega P \int_{-\infty}^{\infty} dCF(\xi, C)(C - \xi x)^{-n},$$

для нечётных n

$$f(x) = \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{2(2\pi)^{n-1}} \int_{\Gamma} d\Omega F_C^{(n-1)}(\xi, \xi x).$$

Здесь Γ — произвольная поверхность в пространстве параметров ξ , окружающая начало координат, а

$$d\Omega = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} d\xi_1 \dots d\xi_{k-1} d\xi_{k+1} \dots d\xi_n.$$

Символом F_C^{n-1} обозначена $(n-1)$ -я производная Р. п. по последнему аргументу.

Ф-лы обращения решают задачу восстановления ф-ции по значениям её интегралов, взятых по всем гиперповерхностям пространства R^n . Эта задача возникает, напр., в томографии, где $f(x)$ характеризует поглощение звука в данной точке x исследуемого объёма, а непосредственно измеряется её Р. п. — интегральные характеристики поглощения в последовательных плоских сечениях.

Лит.: Гедьфанд И. М., Граев М. И., Вилек и др. И. Я., Интегральная геометрия..., М., 1962; Функциональный анализ, под ред. С. Г. Крейна, М., 1964.

В. П. Погов.

РАЗВЕРТКА электронная — перемещение электронного луча в электронно-лучевом приборе (осциллограф, трубка, кинескоп, электронно-опт. преобразователе и т. п.) с целью изучения функциональной зависимости нек-рой физ. величин от независимой переменной.

Наиб. распространено исследование процессов во времени (временная Р.). При рассмотрении исследуемого процесса в прямоугол. системе координат в зависимости от отклоняющей системы электронного луча в качестве временной Р. применяют генераторы пилообразного напряжения или генераторы пилообразного тока. Эти устройства обеспечивают передвижение электронного луча с пост. скоростью и позволяют получить линейный масштаб по оси времени (линейная Р.), в то время как наблюдаемая величина вызывает отклонение вдоль др. оси. В нек-рых случаях информация о наблюдаемой величине осуществляется не отклонением луча, а изменением его яркости. Для наблюдения редко повторяющихся или однократных процессов применяют устройства, способные генерировать одиночные импульсы пилообразного напряжения или тока в момент действия исследуемого процесса (см. Осциллограф, Генератор пилообразного напряжения).

Размеры экрана электронно-лучевой трубки или кинескопа ограничивают длину линейной Р., а следовательно, и возможность детального рассмотрения процесса, длительность больше, чем время прохождения электронного луча по экрану при выбранной скорости Р. Для устранения этого недостатка применяют полярную систему координат и соответственно круговую или спиральную Р. Такие Р. создают одновременно подачей на две взаимно-перпендикулярные отклоняющие системы двух сдвинутых по фазе на 90° синусоидальных напряжений или токов с пост. амплитудой (круговая Р.) или с амплитудой, медленно изменяющейся по сравнению с их периодом (спиральная Р.).

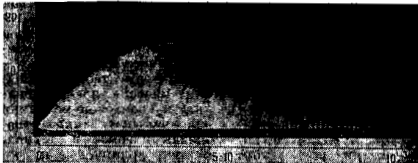
При наблюдении функциональной зависимости изучаемой величины не от времени, а от к-л. другой независимой переменной последняя, в свою очередь, всегда является ф-цией времени. Так, напр., при изучении зависимости анодного тока электронной лампы от

напряжения на её управляющей сетке анодный ток или падение напряжения на известном сопротивлении, пропорциональное этому току, воздействует на одну отклоняющую систему осциллографа. Трубки, а сеточное напряжение (независимая переменная), изменяется по к-л. закону во времени, воздействует на вторую отклоняющую систему. Т. о. время, в явном или неявном виде, всегда участвует в Р.

Наряду с осциллографич. применениями Р. играет весьма важную роль в радиолокации, радионавигации и телевидении.

РАЗВЕРТКА ОПТИЧЕСКАЯ — непрерывное во времени перемещение оптич. изображения самостоятельного или подсвеченного вспомогат. источником света объекта по поверхности светочувств. элемента (фотогр. эмульсия, экрану электронно-опт. преобразователя) с целью исследования быстропротекающих процессов — электрич. разрядов, детонации взрывчатых веществ и газовых смесей, распространения ударных волн, взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом и др. В отличие от скорости кинескопа, при к-рой фиксируют дискретные фазы изучаемого процесса, Р. о. обеспечивают его непрерывную регистрацию.

Р. о. осуществляют либо при неподвижном изображении за счёт движения светочувств. слоя, либо при неподвижном фотослое за счёт движения изображения. В типичной схеме Р. о. первый объект стрит изображение исследуемого объекта в плоскости щели, к-рая выражает из него узкую полосу; при развитии процесса это изображение перемещается вдоль



Фотограмма оптической щелевой развертки плазменного факела, возникающего при взаимодействии лазерного излучения с образцом из меди.

щели, оставаясь в её плоскости. С помощью второго объекта изображение полоски переводится на фотоплёнку, размещённую в виде кольца внутри или снаружи вращающегося барабана, ось вращения к-рого параллельна щели. Подобные системы работают в ждущем режиме, не требуют сложных схем синхронизации и обеспечивают получение развертки процессов с большим разбросом их начала по времени. Линейная скорость вращения плёнки, если она закреплена снаружи барабана, достигает 100 м/с, при закреплении внутри — 300–400 м/с. Разрешающая способность Р. о. по времени равна промежутку времени, за к-рый изображение щели проходит путь, равный её собственной ширине. При ширине изображения 0,1 мм разрешенное по времени может достигать $(2-3) \cdot 10^{-7}$ с. Понимать относят. скорость движения плёнки и изображения объекта позволяет это сделать к а л ь н а я Р. о., при к-рой плёнка неподвижна, а перемещается изображение за счёт отражения от вращающегося плоского зеркала, скорость к-рого может быть значительно больше скорости барабана (до 10^6 об/мин). К тому же при вращении зеркала угл. скорость движения отражённого луча удваивается. Одиночное зеркало может быть заменено зеркальным многогранником (3–12 граней). Линейная скорость Р. о. с зеркальным 12-гранником до $4,5 \cdot 10^8$ м/с. Разрешенное по времени приборов с зеркальной Р. о. при ширине щели 0,1 мм достигает $5 \cdot 10^{-9}$ – $5 \cdot 10^{-8}$ с. Существуют две системы зеркальных Р. о.: 1) система с ограниченным

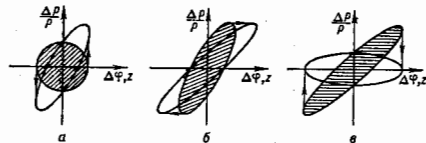
рабочим углом разворота зеркала, требующая синхронизации начала процесса с определ. положением зеркала; 2) система непрерывного действия (ждущая система), при к-рой на фотогр. материале всегда имеется изображение изучаемого явления и фоторегистрация может быть произведена в любой момент времени.

При изучении слабостянутых быстропотекающих процессов Р. о. осуществляется с помощью электривоноотч. преобразователя (ЭОП), к-рый одновременно выполняет роль усилителя яркости. Регистрацию изображения щели, на к-рую спроецировано изображение исследуемого объекта, производят на экране ЭОП с линейной развёрткой, регистрацию точечного изображения — с круговой развёрткой. Последовательное люминесцентное экрана ЭОП позволяет регистрировать сразу всю картину Р. о. обычным фотографированием. Приборы с ЭОП, предназначенные для получения Р. о., имеют предельное разрешение $\sim 10^{12}$ — 10^{13} с (в редких случаях до 10^{14} с) при разрешающей способности на экране 15—20 лия/мм. Пороговая чувствительность системы с ЭОП составляет 10^{-8} — 10^{-9} Дж/см² в области спектральной чувствительности 400—1300 нм.

Лит.: Дубовик А. С., Фотографическая регистрация быстропотекающих процессов, 3 изд., М., 1984; Климин В. Ф., Панырин А. Н., Солоухин Р. И., Оптические методы регистрации быстропотекающих процессов, Новосибир., 1980. Л. Н. Капорский.

РАЗГРУППИРОВАТЕЛЬ (дебанер) — устройство в ускорителях, служащее для выравнивания энергии частиц в сгруппированных пучках (банках). Р. используется гл. обр. для согласования продольных фазовых объёмов при передаче частиц из одного ускорителя в другой (напр., из линейного ускорителя в протонный синхротрон).

Типичная схема Р. включает два резонатора и дрейфовое пространство между ними. На резонаторах (в идеальном случае) создается пилообразное напряжение. В первом резонаторе сгруппиров. пучок возвращается в продольном фазовом пространстве [в плоскости z (или $\Delta\varphi = \Delta p/p$), где $\Delta\varphi$ — отклонение по фазе, z — отклонение по продольной координате, а $\Delta p/p$ — по импульсу] до соответствующих значений для равновесной — центральной — частицы. Первонач. фазовый объём, занятый пучком (круг на рис. а), при этом деформируется, поскольку импульс впереди



летящих частиц увеличивается, а сзади летящих — падает. В дрейфовом пространстве пучок расплывается из-за наличия $\Delta p/p$ и его продольный размер увеличивается до требуемого значения (рис., б). Во втором резонаторе генерируется напряжение обратного знака, уменьшающее $\Delta p/p$ у частиц, летящих впереди, и увеличивающее его у частиц, летящих сзади. В итоге из второго резонатора выходит разгруппиров. пучок частиц с уменьшенным разбросом по импульсу (рис., в). В реальных резонаторах напряжение имеет форму, близкую к синусоидальной, и для разгруппировки используется линейный участок поля. Л. П. Зенкович.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ МЕТОД — метод отделения частных решений математической физики уравнений путём разложения решения, зависящего от полного набора независимых переменных, в произведение сомножителей, зависящих от непересекающихся подвыборов независимых переменных. Если каждый

сомножитель зависит лишь от одного переменного, то разделение переменных наз. полными. Если по крайней мере один из сомножителей зависит от более чем одного независимого переменного, то разделение переменных наз. частичным или Р-разделением.

Решение ур-ния $L u(x_1, \dots, x_n) = 0$ представимо в виде произведения двух сомножителей

$$u(x_1, \dots, x_n) = v(x_1, \dots, x_k) w(x_{k+1}, \dots, x_n),$$

когда дифференц. оператор L можно представить в виде сумм двух операторов L_1 и L_2 , из к-рых L_1 действует только на v , L_2 — только на w :

$$L = L_1 + L_2; L u = (L_1 + L_2) u = (L_1 + L_2) v w = \\ = w L_1 v + v L_2 w = 0.$$

Это позволяет записать исходное ур-ние в виде

$$A v = B w,$$

где левая часть зависит только от x_1, \dots, x_k , правая — только от x_{k+1}, \dots, x_n , что возможно лишь при условии, если A и B порознь равны одной и той же постоянной, называемой константой разделения.

Существование систем координат, в к-рых данное ур-ние допускает разделение переменных, связано со свойствами симметрии ур-ния (его групповыми свойствами). Известны системы координат, в к-рых разделяются переменные всех классич. линейных ур-ний матем. физики (*Лапласа уравнения, волнового уравнения, диффузии уравнения, Шредингера уравнения для разл. потенциалов и др.*) и нек-рых нелинейных уравнений математической физики (напр., обычно-го и модифицированного Кортевега — де Фриза уравнения, Шредингера уравнения нелинейного, Синус-Гордона уравнения). Все специальные функции матем. физики получены при помощи П. м. в ур-ний Лапласа, Гельмгольца и диффузии. Частным случаем П. м. являются понижение порядка динамической системы при выборе в качестве независимой переменной одного из первых интегралов, П-теорема размерностей анализа, нахождение частично инвариантных решений (напр., автомодельных) в теории групповых свойств дифференц. ур-ний.

Лит.: Тихонов А. Н., Самарский А. А., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1977; Владимиров В. С., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1988; Миллер У. Симметрия и разделение переменных, пер. с англ., М., 1981. Ю. А. Далеков.

РАЗДУВАЮЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ (инфляционная Вселенная) — название теории начальной стадии развития Вселенной, предложенной в нач. 80-х гг. 20 в. с целью исправить ряд недостатков стандартного варианта горячей Вселенной теории (см. также Космология).

Согласно теории горячей Вселенной, пространственно-временные свойства Вселенной с большой степенью точности описываются одной из трёх моделей Фридмана — открытой, замкнутой или плоской. Во всех случаях Вселенная должна была родиться в сингулярном состоянии с бесконечно большой плотностью в темп-рой в нек-рый нач. момент времени $t = 0$ (модель Большого Взрыва). При последующем расширении темп-ра Вселенной должна была падать и постепенно достигнуть совр. значения $T \approx 2,7$ К (темп-ра микроволнового фоновое излучения). В дальнейшем замкнутая Вселенная должна была бы снова сжаться до состояния с бесконечной плотностью и темп-рой, а открытая или плоская Вселенная — неограниченно расширяться, продолжая постепенно остывать.

Обладая рядом несомненных достоинств, теория горячей Вселенной в нек-рых отношениях оставалась не вполне удовлетворительной. К нач. 1980-х гг. выяснилось, что в рамках этой теории большинство создава-

емы единых теорий элементарных частиц приводит к космологич. следствиям, несовместимым с данными наблюдений. Так, напр., согласно единым теориям слабых, сильных и эл.-магн. взаимодействий (см. *Великое объединение*), в горячей Вселенной на самых ранних стадиях её существования должно было рождаться много сверхтяжёлых частиц — *магнитных монополей*. Плотность вещества, обусловленная этими частицами, к настоящему моменту должна была бы на 15 порядков превосходить наблюдаемую плотность вещества во Вселенной $\rho_0 \sim 10^{-29}$ г/см³. Теория горячей Вселенной на два ответа на вопросы: что было до Большого Взрыва; почему риманова геометрия, описывающая свойства пространства нашей Вселенной, с такой огромной степенью точности близка к евклидовой геометрии плоского мира; почему наблюдаемая часть Вселенной в ср. является однородной; откуда в этом однородном мире выявилась нач. неоднородности, необходимые для образования галактик; почему разные части Вселенной, сформировавшиеся независимо друг от друга, в настоящее время выглядят практически одинаково; почему все части бесконечной плоской или открытой Вселенной должны были начать своё расширение одновременно. Если же Вселенная замкнута, то было непонятно, как она могла прожить $\sim 10^{10}$ лет, несмотря на то, что типичное время жизни замкнутой горячей Вселенной не должно было бы сильно превосходить т. н. планковское время $t_P \sim M_P^{-1} \sim 10^{-43}$ с (рис. 1).

Здесь, $M_P \sim 10^{19}$ ГэВ — планковская масса, $M_P = \sqrt{G^{-1}}$, где G — гравитационная постоянная [все величины приведены в системе единиц (принятой в теории элементарных частиц), в к-рой скорость света c и постоянная Планка \hbar положены равными единице].
 Ныне приобрели особую популярность *Кауцы* — *Клейма теории* и теория суперструн, согласно к-рым пространство-время Вселенной изначально имело размерность $d > 4$, но в нек-рых направлениях пространство как бы сжалось (скомпактифицировалось) в тонкую трубочку толщиной $l \sim M_P^{-1} \sim 10^{-33}$ см. Поэтому макроскопич. тела не могут двигаться в этих направлениях и пространство-время представляется четырёхмерным. От того, сколько измерений скомпактифицировалось и как именно произошла компактификация, зависят и эфф. размерность пространства Вселенной, и свойства элементарных частиц в нём. Пока не выяснено, почему скомпактифицировалось именно $d-4$ измерения (пространство-время оказалось четырёхмерным) и почему после компактификации (и последующих процессов нарушения симметрии) фив. взаимодействия разделились на слабые, сильные и эл.-магнитные.

Ост. часть этих проблем можно решить (или обойти) в рамках теории Р. В. Общая черта разл. вариантов теории Р. В. — это валентные стадии экспоненциального (или квазиэкспоненциального) расширения Вселенной, находящейся в вакуумоподобном состоянии с большой плотностью энергии. Эту стадию наз. стадией раздувания или инфляции. После раздувания вакуумоподобное состояние распадается, рождающиеся при этом частицы взаимодействуют друг с другом, устанавливается термодинамич. равновесие и последующая эволюция происходит согласно теории горячей Вселенной (рис. 1).

В простейшем варианте теории Р. В. в изначальном вакуумоподобном состоянии находится пространство, заполненное достаточно однородным медленно меняющимся скалярным полем ϕ . Поля такого типа часто фигурируют в единых теориях элементарных частиц (т. н. Хиггса поля). Свойства полей Хиггса во многом схожи со свойствами бозе-конденсата куперовских пар в теории сверхпроводимости (см. *Бозе — Эйнштейна конденсат*). Однако в отличие от обычного бозе-конденсата, однородное скалярное поле ϕ , рассматриваемое в совр. теориях элементарных частиц, выглядит одинаково как для движущегося, так и для покоя-

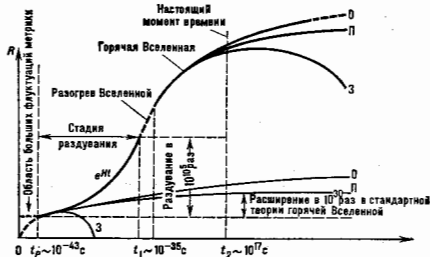


рис. 1. Изменение размера горячей Вселенной (её масштабного фактора R) для трёх моделей Фришмана — открытой (O), плоской (П) и замкнутой (З) (тонкие линии). Жирными линиями изображены возможные пути эволюции раздувавшейся области Вселенной. Изна-а квантовогравитационных флуктуаций классическое описание расширения Вселенной возможно не ранее чем через 10^{-43} с от момента Большого Взрыва (или от момента начала раздувания в данной области), $t = 0$. За время раздувания ($\sim 10^{-36}$ с) раздувающаяся область Вселенной увеличивается в 10^{44} — 10^{60} раз.

щегося наблюдателя. В этом смысле однородное скалярное поле отличается от любой другой матеральной среды, с к-рой можно было бы связать выделенную систему отсчёта (систему покоя среды). С точки зрения возможных проявлений, постоянное скалярное поле ϕ ведёт себя как несколько изменённое вакуумное состояние. Осн. ф-ция полей такого рода в единых теориях элементарных частиц состоит в том, что, по-разному взаимодействуя с разными частицами, поле ϕ меняет их массу и константы связи и тем самым нарушает симметрию между разными типами взаимодействий. Значение таких полей для космологии связано, в первую очередь, с тем, что пост. поле ϕ может иметь большую плотность энергии $V(\phi)$, от величины к-рой зависит скорость расширения Вселенной.

В широком классе теорий, включающем теорию массивного скалярного поля $V(\phi) = (m^2/2)\phi^2$, расширение Вселенной тормозит процесс изменения поля ϕ . При больших значениях $V(\phi)$ расширение идёт быстро, а величина поля ϕ меняется очень медленно. Поэтому плотность энергии $V(\phi)$ в течение большого времени остаётся почти постоянной, т. е., в отличие от плотности обычного вещества, она почти не убывает при расширении Вселенной (плотность энергии вакуума не меняется при расширении). Это в конечном счёте и приводит к экспоненциально быстрому росту (раздуванию) области Вселенной, заполненной большим полем $\Phi_{\text{инф}} \gg M_P$, рис. 2): масштабный фактор

$$R(t) \sim \exp(Ht), \text{ где } H = \sqrt{8\pi V(\phi)/3M_P^2}.$$

Причина того, что расширение Вселенной не приводит к убыванию энергии постоянного скалярного поля, состоит в том, что его тензор энергии-импульса пропорционален метрич. тензору, $T_{\mu\nu}(\phi) = V(\phi)g_{\mu\nu}$ (см. *Тяготемия*). Это соответствует особому ур-нию состояния, связывающему ρ и p — плотность энергии поля ϕ и давление: $\rho = -p = V(\phi)$. При расширении Вселенной плотность энергии должна была бы уменьшаться, $d\rho = -p dV$ — увеличение элемента объёма, но это уменьшение компенсируется за счёт того, что расширяющийся элемент объёма совершает при этом работу $dW = p dV = -p dV$. Именно отрицат. значение давления в состоянии с пост. полем ϕ лежит в основе возможности расширения Вселенной с пост. положит. относн. ускорением $\dot{R}/R \sim H^2$.

После того как поле ϕ становится достаточно малым ($\phi \ll M_P$), скорость расширения и соответствующая

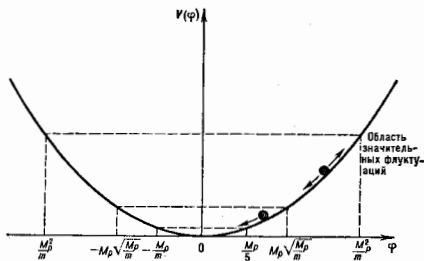


Рис. 2. Эволюция скалярного поля Φ в простейшей теории поля с массой m и плотностью потенциальной энергии $V(\Phi) = (m^2/2)\Phi^2$. В области $\Phi > M_p^2/m$, где $V(\Phi) > M_p^4$, классическое описание пространства в простейших теориях невозможно. При $M_p/5 \leq \Phi \leq M_p^2/m$ поле Φ эволюционирует относительно медленно, а Вселенная расширяется квазиэкспоненциально. При $M_p \sqrt{M_p/m} \leq \Phi \leq M_p^2/m$ амплитуда поля Φ сильно флуктуирует, что ведёт к несконечному рождению новых и новых раздувающихся областей Вселенной. При $M_p/5 \leq \Phi \leq M_p \sqrt{M_p/m}$ флуктуации поля Φ имеют относительно небольшую амплитуду, они приводят к рождению неоднородностей плотности, нужных для образования галактик. При $\Phi \leq M_p/5$ поле начинает быстро осциллировать вблизи точки $\Phi = 0$, рождаются пары частиц, и энергия колеблющегося поля переходит в тепловую энергию родившихся частиц.

тормозящая сила, действующая на поле Φ , уменьшаются. Поле начинает быстро колебаться вблизи минимума значения своей потенц. энергии $V(\Phi)$. При этом поле Φ рождает пары элементарных частиц, отдавая им свою энергию и тем самым разогревая Вселенную.

В типичных моделях стадия раздувания продолжается очень недолго, $\sim 10^{-35}$ с. Однако за это время раздувающаяся Вселенная успевает увеличить свой размер в $(10^8 - 10^{10})$ раз (точные цифры зависят от выбора конкретной теории элементарных частиц и механизма, обеспечивающего раздувание). После столь сильного расширения геометрия пространства внутри раздувающейся области Вселенной становится практически неотличимой от евклидовой геометрии плоского мира, подобно тому как геом. свойства поверхности воздушного шара по мере его раздувания всё меньше и меньше отличаются от свойств плоскости. Раздувание Вселенной приводит к тому, что монополи и др. неоднородности оказываются преим. за пределами её наблюдаемой в совр. эпоху части размером $l_0 \sim 10^{26}$ см. Это одновременно решает проблемы однородности наблюдаемой Вселенной и малочисленности в ней монополей. Поскольку вся наблюдаемая часть Вселенной образовалась за счёт раздувания одной области ничтожно малого размера, нет ничего удивительного в том, что свойства различных удалённых друг от друга областей видимого нами мира оказываются в ср. одинаковыми.

Во время раздувания (инфляции) квантовые флуктуации скалярного поля Φ , неизбежно присутствующие в вакууме, приобретают всё большую и большую длину волны, растягиваясь вместе с расширением Вселенной. Когда длина волны данной флуктуации Φ начинает превосходить величину H^{-1} , поле Φ перестаёт флуктуировать, его амплитуда «замораживается», а длина волны продолжает экспоненциально расти. Это приводит к непрерывному процессу генерации неоднородностей поля Φ с большой длиной волны ($l \gg H^{-1}$), а они в свою очередь порождают неоднородности плотности, нужные для последующего образования галактик (см. *Черевичные флуктуации* в ранней Вселенной).

Флуктуации поля Φ играют и ещё одну, более фундаментальную роль. Если поле Φ достаточно велико ($\Phi > M_p \sqrt{M_p/m}$, рис. 2), то его уменьшение за счёт медленного сжатия к минимуму $V(\Phi)$ оказывается несущественным по сравнению с флуктуативным изменением поля Φ . В результате этого процесса в нек-рой части нач. объёма поле Φ не уменьшается, а увеличивается. В то же время Вселенная продолжает быстро расширяться, так что полный объём, занятый увеличивающимся полем Φ , не уменьшается, а экспоненциально растёт, причём тем скорее, чем больше поле Φ . Т. о., любая область $R. В.$, содержащая достаточно большое (и достаточно однородное) поле Φ , постоянно порождает новые и новые раздувающиеся области с большим полем Φ , и этот процесс продолжается бесконечно. В рамках этих представлений эволюция всей Вселенной в целом не имеет конца и может не иметь единого сингулярного начала, до к-рого пространство и время вообще не существовали (рис. 3).

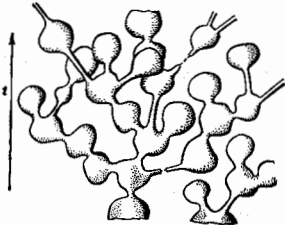


Рис. 3. Возможная глобальная структура раздувающейся Вселенной. Одна раздувающаяся область порождает много новых областей, в которых свойства пространства-времени и законы взаимодействия элементарных частиц друг с другом могут быть различными.

В реальности, теория элементарных частиц, кроме поля Φ , обеспечивающего раздувание, существует большое кол-во др. типов скалярных полей Φ , а их потенц. энергия $V(\Phi)$ зачастую имеет много локальных минимумов. Флуктуации, генерирующиеся во время раздувания, приводят к рождению рацл. экспоненциально больших областей, заполненных разными полями Φ , соответствующими всем возможным минимумам энергии $V(\Phi)$. Квантовые флуктуации в областях с очень большими значениями поля Φ [При $V(\Phi) \sim M_p^4$, рис. 2] могут приводить к формированию раздувающихся областей Вселенной с др. типами компактификации. В результате Вселенная разбивается на много экспоненциально больших областей (рис. 3), внутри к-рых размерность пространства-времени, тип компактификации и свойства элементарных частиц могут быть различными (т. н. доменная структура Вселенной). Мы живём в 4-мерном пространстве-времени, в к-ром существуют известные нам типы взаимодействий, но не исключено, что это происходит не потому, что только так и может быть устроен мир. Возможно, что в разных частях Вселенной могут реализовываться все мыслимые состояния, но жизнь известного нам типа возникает только в 4-мерном пространстве-времени с вполне определ. типами взаимодействий между элементарными частицами. Области Вселенной с иными свойствами, согласно теории Р. В., находятся от нас на расстояния, а много порядков превышающем размеры наблюдаемой части Вселенной.

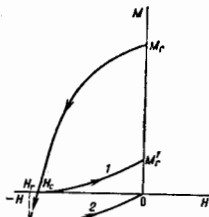
Т. о., теория Р. В. приводит к пересмотру существовавших ранее представлений о самых ранних стадиях эволюции наблюдаемой части Вселенной, о структуре Вселенной в целом и о нашем месте в мире. Ста-

для раздвигания представляется сейчас необходимыми элементом космологич. эволюции. Вместе с тем вполне возможно, что окочат. вариант теории Р. В. в определ. чертах будет отличаться от простейших моделей, обсуждаемых выше.

Лит.: Линде А. Д., Физика элементарных частиц и инфляционная космология, М., 1990. А. Д. Линде. **РАЗМАГНИЧИВАНИЕ** — процесс, в результате к-рого уменьшается намагниченность магн. материала (образца). Частичное Р. происходит уже при снижении напряженности H намагничивающего поля до нуля. Особенно большое уменьшение намагниченности M при этом происходит в образцах незамкнутой формы под влиянием их собств. размагничивающего поля, направленного антипараллельно намагниченности. Такое Р. не может быть полным, и образец после него сохраняет остаточную намагниченность M_r . Полное Р., т. е. снижение M_r до нуля, может быть достигнуто тремя способами.

1. Р. в состоянии магнитным полем. Если на образец воздействовать магн. полем H , антипараллельным его остаточной намагниченности M_r , последняя снижается и при нек-ром значении этого поля H_c , называемом *коэрцитивной силой*, становится равной нулю (рис.). После выключения внеш. размагничивающего поля намагниченность становится частично восстанавливается по кривой возврата 1 до значения M_r .

Размагничивание постоянным магнитным полем H ; M — намагниченность образца; M_r — остаточная намагниченность; H_c — коэрцитивная сила; H_r — релаксационная коэрцитивная сила.



Можно подобрать такое размагничивающее внеш. поле $|H_c| > |H_c|$, после выключения к-рого значение M_r образца станет равным нулю (кривая возврата 2), т. е. он окажется размагниченным. В отличие от H_c , поле H_r вызывает релаксацию и оной коэрцитивной силой. Участок петли *гистерезиса магнитного*, находящийся во втором квадранте между точками M_r и H_c , наз. кривой размагничивания.

2. Р. в переменном магнитном поле. При воздействии на образец в состоянии остаточной намагниченности перемен. полем с амплитудой, убывающей от значения, заведомо превышающего коэрцитивную силу, до нуля, достигается его полное Р.

3. Р. в сравнении с образцом выше *Кюри точки*. При таком нагреве вообще утрачивается ферромагн. упорядочение вещества. Если после этого образец охлаждается в отсутствие магн. поля, он оказывается полностью размагниченным.

Хотя все три способа Р. приводят к нулевой значению намагниченности, характер *магнитной доменной структуры*, создаваемой каждым из них, различен, что приводит к различию и нек-рых свойств вещества (напр., начальной магн. восприимчивости, магнито-стрикции).

При Р. в веществе наблюдаются те же процессы, что и при намагничивании, только идут они в обратном направлении. Наряду с этим имеется и нек-рая особенность процессов Р., связанная с образованием доменов с обратной намагниченностью (зародышей *перемагничивания*). Задержка в возникновении и (или) росте таких зародышей является одной из причин *гистерезиса магнитного*.

Р. широко применяется в технике. Так, после мех. технол. операций детали из ферромагн. материалов оказываются намагниченными, это может служить источником помех при работе содержащих эти детали устройств и механизмов. Поэтому такие детали подвергают Р. При измерении магн. характеристик материалов также применяют Р. образцов.

Лит. см. при ст. *Намагничивание*. А. С. Ермаков. **РАЗМАГНИЧИВАЮЩИЙ ФАКТОР** (коэффициент размагничивания) — отношение размагничивающего магн. поля H_d в намагниченном теле к намагниченности M этого тела. Для тела произвольной формы, помещенного в бесконечно большое внеш. магн. поле,

$$\mu_0 H_d = -\|N\|M,$$

где μ_0 — *магнитная постоянная*, M — вектор намагниченности в точке измерения H_d . $\|N\|$ — Р. ф., являющийся в общем случае зависящим от координат *тензором*. Только тела в форме эллипсоидов, изготовленные из однородного магн. материала и находящиеся в однородном магн. поле, имеют однородное размагничивающее поле. Для таких тел $H_d = \|N\|$ и M не зависят от координат точки в объеме тела. Если эллипсоид намагнитить вдоль одной из его гл. осей a, b или c (напр., вдоль a), то H_d и M параллельны этой оси и $\mu_0 H_d = -N_a M_a$. Для эллипсоидов вращения ($b = c$) значение N_a может быть вычислено по ф-лам

$$N_a = \frac{1}{\nu^2 - 1} \left[\frac{\nu}{(\nu^2 - 1)^{3/2}} \ln(\nu + \sqrt{\nu^2 - 1}) - 1 \right] \text{ при } \nu = \frac{a}{b} > 1 \text{ (овоид)},$$

$$N_a = \frac{1}{1 - \nu^2} \left[1 - \frac{\nu}{(1 - \nu^2)^{3/2}} \arccos \nu \right] \text{ при } \nu = \frac{a}{b} < 1 \text{ (сфероид)}.$$

В единицах СИ $N_a + N_b + N_c = 1$, поэтому для однородного шара $N_a = N_b = N_c = 1/3$.

При намагничивании полностью размагниченного эллипсоида вдоль одной из его гл. осей намагнич. поле остается однородной и параллельной внеш. полю H_e при всех его значениях, а соответствующий Р. ф. не зависит от намагниченности. Поэтому, напр., по кривой намагничивания $M_d(H_e)$ может быть вычислена кривая $M_a(H_i)$, где H_i — внутреннее поле $H_i = H_e - \mu_0^{-1} N_a M_a$.

В практике магн. измерений различают магн. и метрический и баллистический Р. ф. Первый применяется при измерении усредненной по объему всего тела намагниченности $M_{ср}$. Второй используется при баллистич. методе измерения намагниченности, когда определяется среднее по поперечному сечению в центр. части образца значение намагниченности. В силу однородности намагниченности для эллипсоида нет различия между этими Р. ф. В случае тел др. формы (напр., призм, цилиндров) обычно магнитометрический Р. ф. больше баллистического, причём оба зависят от магн. свойств материала и характера распределения локальных значений намагниченности в образце. Для тел неэллипсоидальной формы Р. ф. сложным образом зависят не только от формы, но и от магн. свойств материала, распределения намагниченности в образце и координат точки наблюдения. Эмпирич. значения Р. ф. для тел разной формы (обычно цилиндров) приводятся в виде таблиц или графиков. При использовании приводимых в справочниках значений Р. ф. следует учитывать, для каких материалов и при каких условиях измерений они были определены.

Лит.: Аркадьев В. К., Электромагнитные процессы в металлах, ч. 1, М.—Л., 1934; Кифер И. И., Испытания ферромагнитных материалов, 3 изд., М., 1969; Поливанов К. М., Ферромагнетизм, М.—Л., 1957; Таблицы физических величин, Сиравоичник, М., 1976, с. 545—48.

«РАЗМЕР» ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЫ — характеристика частицы, отражающая распределение по прост-

ранству её массы или электрич. заряда; обычно говорят о т. н. среднеквадратичном радиусе распределения электрич. заряда (к-рый одновременно характеризует и распределение массы)

$$\langle r^2 \rangle^{1/2} = \left[\int \rho_e(r) r^2 d^3r \right]^{1/2},$$

где ρ_e — нормированная плотность заряда $\int \rho_e(r) d^3r = 1$.

Элементарные частицы принято разделять на три осн. группы: калибровочные бозоны (промежуточные векторные бозоны, фотон, глюоны), лептоны и адроны. Частицы первых двух групп могут быть названы истинно элементарными. Адроны являются составными системами, построенными из кварков, и, строго говоря, элементарными частицами не являются. Соответственно резко различаются «размеры» частиц этих групп.

Калибровочные бозоны и лептоны в пределах точности выполненных измерений не обнаруживают конечных «размеров». Это означает, что их «размеры» $< 10^{-18}$ см (по оценке на нач. 1990-х гг.). Если и в дальнейших экспериментах конечные «размеры» у этих частиц (а также кварков) не проявятся, то это может свидетельствовать о том, что «размеры» калибровочных бозонов, лептонов и кварков исчезающе малы и близки по порядку величины к фундаментальной длине (к-рая может оказаться близкой к планковской, 10^{-33} см).

В отличие от истинно элементарных частиц «размеры» адронов конечны. Их характерный среднеквадратичный радиус определяется радиусом конфайнмента (или удержания кварков) и по порядку величины близок 10^{-13} см. При этом он, конечно, варьирует от адрона к адрону.

Наиб. надёжно измерены среднеквадратичные радиусы, характеризующие распределение электрич. заряда протона, заряженных π -мезонов и К-мезонов (см. Мезоны). Среднеквадратичный радиус распределения заряда связан простой ф-лой с формфактором частиц $F(q^2)$ (Фурье-образом их плотности заряда, $F(q^2) = \int \rho_e \exp(iq \cdot r) d^3r$). Здесь q^2 — квадрат трёхмерного импульса, передаваемого в процессе рассеяния. При малых q^2

$$F(q^2) = 1 - \frac{1}{6} \langle r^2 \rangle q^2 + \dots$$

Измерение формфакторов протона в экспериментах по рассеянию на нём электронов, а также формфакторов π - и К-мезонов в экспериментах по рассеянию последних на электронах вещества позволило определить соответствующие среднеквадратичные радиусы:

$$\langle r_p^2 \rangle^{1/2} = (0,814 \pm 0,015) \cdot 10^{-13} \text{ см},$$

$$\langle r_{\pi^\pm}^2 \rangle^{1/2} = (0,663 \pm 0,023) \cdot 10^{-13} \text{ см},$$

$$\langle r_{K^\pm}^2 \rangle^{1/2} = (0,53 \pm 0,05) \cdot 10^{-13} \text{ см}.$$

Ошибки отражают уровень точности выполненных экспериментов.

РАЗМЕРНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ в квантовой теории поля — формальный приём, позволяющий использовать для характеристики взаимодействия квантовых полей размерный параметр вместо безразмерной константы связи, фигурирующей в лагранжиане взаимодействия классич. полей.

Благодаря квантовым эффектам поляризации вакуума безразмерная числовая характеристика классич. теории полей — константа связи g превращается в ф-цию квадрата 4-импульса, $\bar{g}(k^2)$, называемую эфф. к-тивной константой связи или эфф. эффективн. зарядом. Эта ф-ция, рассматриваемая на плоскости

k^2, \bar{g} , характеризуется двумя координатами — размерной абсциссой $k^2 = \mu^4$ и безразмерной ординатой $\bar{g} = g_\mu$. Новый размерный параметр μ связан с условиями измерения, и, напр., в случае квантовой электродинамики, когда роль g играет квадрат эфф. заряда электрона α , μ^2 равен квадрату 4-импульса фотона, при помощи к-рого измеряется заряд электрона.

В частных случаях благодаря специфике поведения ф-ции эфф. заряда $\bar{g}(k^2)$ факт наличия двух параметров, характеризующих интенсивность взаимодействия системы квантовых полей, может быть «затушеван». Так, в квантовой электродинамике, исходя из очевидных требований соответствия с классич. макроскопич. случаем, долгое время использовали «графиконное значение» квадрата эфф. заряда электрона $\alpha = \bar{\alpha}(k^2 = 0)$, равное его миллионковому значению $1/137$. С др. стороны, после обработки одноплетевого приближения теории возмущений методом ренормализации, группы для эфф. заряда получают выражение, имеющее вид суммы геом. прогрессии. Напр., в квантовой хромодинамике (КХД) одноплетевые ренормгрупповые приближения для эфф. константы связи α_s [ср. с ф-лой (4) в ст. Ренормализационная группа] имеет вид

$$\frac{d\alpha_s}{d\ln k^2} = -\frac{\alpha_s}{1 + \alpha_s b_1 \ln(k^2/\mu^2)} \quad (1)$$

(b_1 — число). Это выражение с помощью подстановки $\alpha_s = [b_1 \ln(\mu^2/\Lambda^2)]^{-1}$ может быть приведено к виду

$$\frac{d\alpha_s}{d\ln k^2} = \frac{1}{b_1 \ln(k^2/\Lambda^2)}, \quad (2)$$

в к-ром два параметра μ и α_s входят через одну комбинацию

$$\Lambda = \mu \exp(1/2b_1\alpha_s).$$

Как видно, параметр Λ даёт ординату полюсной особенности одноплетевого приближения и поэтому также является характеристикой краевого тина. С фив. точки зрения, величина Λ , называемая параметром шкалы КХД, характеризует масштаб импульсной переменной $k = \sqrt{|k^2|}$, при к-рой α_s принимает значения, большие единицы, т. е. соответствует сильной связи.

Т. о., возможность Р. т. «в чистом виде», т. е. «превращения» одной безразмерной константы связи в одну размерную — параметр шкалы, является следствием специфики ренормгрупповой структуры выражения для эфф. заряда.

Лит. см. при ст. Ренормализационная группа.

РАЗМЕРНОСТЕЙ АНАЛИЗ — метод установления связи между физ. величинами, существенными для изучаемого явления, основанный на рассмотрении размерностей единиц этих величин.

В основе Р. а. лежит требование: ур-ние, выражающее искомую связь, должно оставаться справедливым при любом изменении единиц входящих в него величин. Если это требование выполняется, то размерности в левой и правой частях ур-ния совпадают; если этого не происходит, то изменение к.-л. физ. величины вызовет разные изменения в обеих частях ур-ния и равенство нарушится. Неравенство размерностей левой и правой частей ур-ния может означать, что не учтена к.-л. величина, существенная для данного явления, либо в ур-ние должна входить неучтённая размерная константа. Напр., ур-ние для периода колебаний матем. маятника, длина к-рого l и масса m , можно записать в виде

$$T = l^2 m \nu,$$

а для размерностей оно будет иметь вид

$$T = LM,$$

т. е. для размерностей равенство не выполняется. Однако известно, что колебания маятника происходят под действием силы тяжести, т. е. в ур-ние для t нужно ввести ускорение свободного падения g :

$$\tau = l^2 m \nu g^2.$$

Тогда для размерностей получим

$$T = L^2 M^0 (LT^{-2})^2,$$

а для показателей размерностей — систему ур-ний

$$x + z = 0; y = 0; 2z = -1.$$

Т. е. $z = -1/2$, $x = 1/2$, $y = 0$. И искоемое ур-ние имеет вид

$$\tau = C \left(\frac{l}{g} \right)^{1/2}.$$

Безразмерный коэф. C , равный, согласно законам механики, 2 π , методом Р. а. определить нельзя. Т. о., ур-ния связи между физ. величинами устанавливаются методом Р. а. с точностью до пост. коэффициентов. Поэтому Р. а. не является универсальным, однако он найдет применение в гидравлике, аэродинамике и др. областях, где строгое решение задачи часто натакаивается на значит. трудности. При решении сложных задач на основе Р. а. используют т. п. л-теорему, согласно к-рой всякое соотношение между нек-рым числом размерных величин, характеризующих данное физ. явление, можно представить в виде соотношения между меньшим числом безразмерных комбинаций, составленных из этих величин. Эта теорема связывает Р. а. с теорией подобия, в основе к-рой лежит утверждение, что если все соответствующие безразмерные характеристики (*подобия критерии*) для двух явлений одинаковы, то эти явления физически подобны (см. *Подобия теория*).

Лит.: Бриджмен П. В. Анализ размерностей, пер. с англ., Л.—М., 1934; Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике, 10 изд., М., 1987; Коган В. Ю., Размерность физической величины, М., 1968; Сена Л. А., Единицы физических величин и их размерности, 3 изд., М., 1989.

Л. А. Сена.
РАЗМЕРНОСТЕЙ ТЕОРИЯ — см. *Размерностей анализ*.

РАЗМЕРНОСТЬ единицы физической величины, или просто размерность величины, — выражение, показывающее, во сколько раз изменится единица данной величины при известном изменении единиц величин, принятых в данной системе за основные. Р. представляет собой одночлен (его заключают в квадратные скобки или превращают физ. величину символом $[A]$, от лат. *dimensio* — измерение), составленный из произведения обобщенных символов осн. единиц в различных (целых или дробных, положит. или отрицат.) степенях, к-рые наз. показателями Р. Если основными являются единицы величины A , B и C , а единица производной величины D пропорциональна единицам величины A в степени x , величины B в степени y и величины C в степени z , то Р. единицы величины D запишется в виде произведения

$$[D] = [A]^x [B]^y [C]^z \text{ или } \dim D = A^x B^y C^z.$$

Если единица величины D не зависит от размера единицы к.-л. из осн. величин, то D обладает в д. е. в о.й Р. по отношению к этой осн. величине. Если единица величины D не зависит от размера ни одной из осн. единиц, то такая величина наз. безразмерной.

Выбор величин, единицы к-рых принимаются за основные, а также размер этих единиц, вообще говоря, произвольны и определяют систему единиц измерений. В *Международной системе единиц* (СИ) таких величин семь: длина (L), масса (M), время (T), сила тока (I), температура (θ), сила света (I), кол-во вещества (N); в скобках приведены символы этих величин в ур-ниях Р.

Единицей кол-ва вещества в СИ является моль —

кол-во вещества, содержащее столько же структурных элементов N (атомов, молекул, нуклонов и т. п.), сколько атомов содержится в углероде массой 0,012 кг.

Р. единицы производной величины зависит не только от выбора осн. величин, но и от определяющего её в данной системе единиц ур-ния. Р. одной и той же физ. величины может оказаться разной при её определении на основании разл. ур-ний. Так, если Р. силы F определяется на основании 2-го закона Ньютона, то при осн. величинах L, M, T

$$[F] = LMT^{-2},$$

а при тех же осн. единицах Р. силы, полученная в основании закона всемирного тяготения, выглядит иначе:

$$[F] = L^{-2}M^2.$$

Если в качестве определяющего ур-ния служит 3-й закон Кеплера, то единица массы окажется производной с $R. [m] = L^3 T^{-2}$, а единица силы приобретает Р. $[F] = L^2 T^{-4}$. [Нужно иметь в виду, что при сведениях ур-ний Р. в определ. систему единиц появятся размерные коэф. такие, чтобы Р. (и размер) единицы физ. величины стала принятой в данной системе единиц.]

Р. иногда считают характеристикой производной величины, отражающей её связь с основными. Однако в Р. часто входят также осн. величины, от к-рых данная величина вообще не зависит (напр., в Р. механик. напряжения входит время, от к-рого оно вообще не зависит, а электрич. ёмкость, к-рая для геометрически подобных проводников пропорциональна их линейным размерам, в СИ имеет Р. $[C] = L^{-2}M^{-1}T^4$). См. также *Размерностей анализ*.

Л. А. Сена.
РАЗМЕРНОСТЬ ГРУППЫ L и — количество числов параметров, с помощью к-рых определяются элементы группы. Группа L является одновременно гладким многообразием, поэтому Р. г. ли $\dim G$ совпадает с размерностью этого многообразия, т. е. с числом координат на нём. Размерность комплексной группы L вдвое больше размерности соответствующей вещественной группы L_r . Нек-рые группы, наиб. часто используемые в физике, имеют следующие размерности (n — размерность пространства, в к-ром действует группа): $\dim GL(n, C) = 2n^2$, $\dim U(n) = n^2$, $\dim SU(n) = n^2 - 1$, $\dim SO(2n) = n(2n - 1)$, $\dim SO(2n + 1) = n(2n + 1)$, $Sp(n) = n(2n + 1)$.

Лит. см. при ст. *Группы*.

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ — зависимость физ. характеристик твёрдого тела от его размеров и форм, когда один из его геом. размеров, напр. толщина d пластины, порядка (или меньше) длины волны де Бройля (см. *Квантовые размерные эффекты*) либо длины свободного пробега l квазичастиц, реализующих энергетич. спектры твёрдого тела (электронов проводимости, фононов, магнонов и др.), или др. макроскопич. параметров, характеризующих движение квазичастиц (классической Р. э.). Ниже рассматриваются классические Р. э.

Р. э. проявляются в зависимости от d кинетич. коэф. (электропроводности, теплопроводности и др.), описывающих линейный отклик тела на внеш. возмущения (электрич. поле, градиент темп-ры и др.), приложенные в плоскости пластины либо вдоль осн. проводки для *нитевидного кристалла*. Эта зависимость обусловлена рассеянием квазичастиц границей образца. При столкновении с поверхностью импульсы падающей на поверхность квазичастицы (p) и отражённой от поверхности (p') могут быть строго скоррелированы (зеркальное отражение) от идеально гладкой бездефектной поверхности) либо частично скоррелированы (или коррелированы) полностью отсутствуют (диффузное отражение). Если на поверхности адсорбированы примесные атомы либо поверхность слабо шероховата (дефекты), то столкновения квазичастиц с поверхностью описываются укл. распределением импульсов отраженных электронов

p' , яв. индикатрисой рассеяния $w(p, p')$. Она зависит от поверхности. Как правило, зависимость кинетич. коэф. от d характерна для диффузного отражения квазичастиц. Однако и при их зеркальном отражении идеально гладкой поверхностью, т.е. в отсутствие рассеяния, проявляются Р.э. (см. *Осцилляции Зонд-лямера*, *Статистический скин-эффект*).

Р.э. удобнее наблюдать в тонких плёнках и питевидных кристаллах при низких темп-рах, когда длина свободного пробега квазичастиц достаточно велика, $d \ll l$. Т.к. в выражении для кинетич. коэф. входят эфф. ширина w индикатрисы рассеяния, то Р.э. служат методом исследования поверхности твёрдого тела с помощью собств. квазичастиц. С др. стороны, существование доминирун. параметра d расширяет возможности изучения квазичастиц, в частности электронов проводимости. Так, Р.э. позволяют определить все *эффективные массы* электронов, их скорость и кривизну в любой точке поверхности Ферми и т.п.

Размерные эффекты в электропроводности. Падение уд. электропроводности проводников с уменьшением d впервые объяснил Дж. Дж. Томсон (J. J. Thomson) в 1906. Вероятность зеркального отражения свободных носителей заряда (для определенности электронов) от поверхности (параметр зеркальности) имеет вид

$$q = 1 - \int_{p'} w(p, p') dp'$$

При этом q существенно зависит от угла падения θ электрона на границу: $q = 1 - \cos^2 \theta$ ($\theta \leq \pi/2$). С ростом θ отражение электронов приближается к зеркальному, при $\theta \rightarrow \pi/2$ $q \rightarrow 1$.

Зависимость $\sigma(d)$ в тонких пластинах и проволоках различна (рис. 1, 2). В проволоках имеет место соотношение

$$\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto (d/l) \ln(l/d),$$

где σ_{∞} — уд. электропроводность массивного проводника. В пластинах

$$\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto (d/l)^{1/2}.$$

Р.э. проявляются в температурной зависимости σ . В чистых проводниках (с шероховатой поверхностью), когда электроны в объёме рассеиваются на фононах (*Рассеяние носителей заряда*), σ падает с ростом T и существенно зависит от w . Чем меньше w , тем меньше различаются σ_d и σ_{∞} . При $d/l < T/\theta_d$ (θ_d — *Дебая температура*) в пластинах $\sigma_d \propto d^2 T^{-1/2}$, в проволоках $\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto d T^{1/2} \ln(T/d)$.

В полуметаллах и многодолинных полупроводниках зависимость $\sigma(d)$ проявляется в достаточно толстых образцах, когда d сравнимо с длиной $l = v_{\text{фрел}} \tau$, где v — ср. скорость электронов, $\tau_{\text{фрел}}$ — время их медленной релаксации между долинами. Наблюдаемые для В1 два падающих участка в зависимости $\sigma(d)$ объясняются возникновением электрич. поля, компенсирующего поперечные токи. Поле обусловлено искривлением энергетич. зон у границ образца.

Размерные эффекты в теплопроводности. В металлах перенос тепла осуществляется электронами и фононами, но электронная компонента — доминирующая. При $T > \theta_d$ и при достаточно низких темп-рах, когда электрон-фононное рассеяние мало по сравнению с электрон-примесным, вклад электронов в коэф. теплопроводности κ^0 определяется *Видемана — Франца законом*, т.е. повторяет зависимость $\sigma(d)$. При $T \lesssim \theta_d$, когда существенно электрон-фононное рассеяние, электронная теплопроводность в пластинах $\kappa^0 \propto (d/l)^{1/2}$. В проволоках $\kappa^0 \propto \sigma(d)$, но с ними, чем в законе Видемана — Франца, коэф. пропорциональности.

В диэлектриках перенос тепла осуществляется гл. обр. фононами. При низких темп-рах, когда все фононы имеют одинаковые скорости v (скорость звука, см. *Дебая теория*), коэф. фоновой теплопроводности

$$\kappa = c(T)sl(T),$$

где $c \propto T^3$ — теплоёмкость единицы объёма, l — ср. длина пробега фононов (см. *Дебая закон теплоёмкости*), $sl(T)$ — эфф. длина пробега фононов, l — эфф. длина пробега фононов, l — эфф. длина пробега фононов, l — эфф. длина пробега фононов. Наряду с т.н. нормальными «соударениями» фононов с сохранением суммарного квазиимпульса, не приводящими к сопротивлению потоку фононов (длина пробега l_N), происходят столкновения с потерей квазиимпульса — *переворота процессы* или *U-процессы* (длина пробега $l_U \propto \exp(\theta_d/T)$). В массивных бездефектных образцах эфф. длина пробега l определяется величиной l_U . С повышением темп-ры l_U (и, следовательно, κ) возрастает до тех пор, пока не становится равной размеру образца d . При дальнейшем охлаждении l не изменяется, а κ убывает как T^3 (максимум κ соответствует $l = d$).

При $T \ll \theta_d$ вероятность *N-процессов* значительно больше вероятности *U-процессов*, т.е. $l_N \ll l_U$. В ограниченном температурном диапазоне, определяемом условием $l_N \ll d \ll l_U$, сопротивление потоку фононов создаёт только их столкновения с границами, хотя *N-процессы* происходят чаще. Теплопроводность такой пластины (проволоки) определяется т.н. гидродинамич. потоком фононов, аналогичным Пуазейлевскому течению жидкости, при l — перемещение фонона представляет собой случайное блуждание (броуновское движение). Можно показать, что фонон в ср. между соударениями со стенками за счёт *N-процессов* проходит путь $l \propto d^2/l_N$. Т.о., в области $l_N \ll d \ll l_U$ $\kappa \propto d^3/l_N$. Рост l с повышением T происходит до тех пор, пока *U-процессы* не начинают конкурировать с рассеянием на границах. При дальнейшем нагревании κ резко падает. Переход к гидродинамич. режиму осуществляется прохождением через максимум $\kappa(T)$ (рис. 3).

Теплопроводность магнетиков (ферритов, антиферромагнетиков) обусловлена движением не только фононов и электронов, но и маг-

Р.э. проявляются в температурной зависимости σ . В чистых проводниках (с шероховатой поверхностью), когда электроны в объёме рассеиваются на фононах (*Рассеяние носителей заряда*), σ падает с ростом T и существенно зависит от w . Чем меньше w , тем меньше различаются σ_d и σ_{∞} . При $d/l < T/\theta_d$ (θ_d — *Дебая температура*) в пластинах $\sigma_d \propto d^2 T^{-1/2}$, в проволоках $\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto d T^{1/2} \ln(T/d)$.

Р.э. проявляются в температурной зависимости σ . В чистых проводниках (с шероховатой поверхностью), когда электроны в объёме рассеиваются на фононах (*Рассеяние носителей заряда*), σ падает с ростом T и существенно зависит от w . Чем меньше w , тем меньше различаются σ_d и σ_{∞} . При $d/l < T/\theta_d$ (θ_d — *Дебая температура*) в пластинах $\sigma_d \propto d^2 T^{-1/2}$, в проволоках $\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto d T^{1/2} \ln(T/d)$.

Р.э. проявляются в температурной зависимости σ . В чистых проводниках (с шероховатой поверхностью), когда электроны в объёме рассеиваются на фононах (*Рассеяние носителей заряда*), σ падает с ростом T и существенно зависит от w . Чем меньше w , тем меньше различаются σ_d и σ_{∞} . При $d/l < T/\theta_d$ (θ_d — *Дебая температура*) в пластинах $\sigma_d \propto d^2 T^{-1/2}$, в проволоках $\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto d T^{1/2} \ln(T/d)$.

Р.э. проявляются в температурной зависимости σ . В чистых проводниках (с шероховатой поверхностью), когда электроны в объёме рассеиваются на фононах (*Рассеяние носителей заряда*), σ падает с ростом T и существенно зависит от w . Чем меньше w , тем меньше различаются σ_d и σ_{∞} . При $d/l < T/\theta_d$ (θ_d — *Дебая температура*) в пластинах $\sigma_d \propto d^2 T^{-1/2}$, в проволоках $\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto d T^{1/2} \ln(T/d)$.

Р.э. проявляются в температурной зависимости σ . В чистых проводниках (с шероховатой поверхностью), когда электроны в объёме рассеиваются на фононах (*Рассеяние носителей заряда*), σ падает с ростом T и существенно зависит от w . Чем меньше w , тем меньше различаются σ_d и σ_{∞} . При $d/l < T/\theta_d$ (θ_d — *Дебая температура*) в пластинах $\sigma_d \propto d^2 T^{-1/2}$, в проволоках $\sigma_d / \sigma_{\infty} \propto d T^{1/2} \ln(T/d)$.

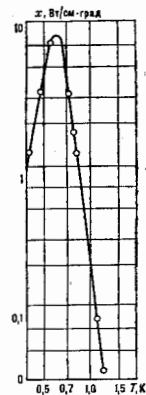


Рис. 3. Зависимость теплопроводности монокристаллов В1 от температуры.

новов. Энергия магновов зависит от магн. поля. Вклад магновов в теплопроводность можно оценить по зависимости $\kappa(H)$. В ней, как и в зависимости $\kappa(T)$, проявляется рассеяние магновов границей образца (см. *Сильные токи*).

Всплески электромагнитного поля в проводнике. Эл.-магн. волны в осн. отражаются поверхностью проводника, проникая в него на небольшую глубину скин-слоя δ (см. *Скин-эффект*). Электроны, движущиеся от поверхности, уносят информацию об эл.-магн. поле в скин-слое в глубь проводника на расстояние порядка длины свободного пробега l . В условиях аномального скин-эффекта ($\delta \ll l$) электроны, «улетающие» от поверхности на сравнительно далекие расстояния, усложняют зависимость эл.-магн. поля (ВЧ-поля) от расстояния x . Сильное магн. поле H (при k -ром радиус электронной орбиты $r \ll l$), параллельное поверхности образца, препятствует дрейфу электронов в глубь проводника, и ВЧ-поле при $\delta \ll r \ll l$ проникает в проводник по цепочке электронных орбит в виде узких всплесков (рис. 4).

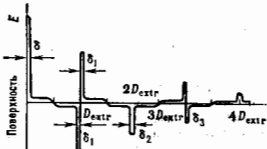


Рис. 4. Распределение ВЧ-поля E по глубине x металла с шероховатой поверхностью при аномальном скин-эффекте в магнитном поле, параллельном его поверхности.

Наиб. эффективно взаимодействуют с ВЧ-полем электроны на тех участках траектории, где они движутся вдоль волнового фронта, т. е. почти параллельно поверхности металла. Это достигается, когда компонента скорости v_x совпадает или близка к фазовой скорости волны v_{ϕ} (точка А, рис. 5). При этом эфф. электроны движутся синхронно с волной в скин-слое, а затем создают ВЧ-ток на расстоянии D , где вновь $v_x = v_{\phi}$ (точка В). Поскольку орбиты электронов с разными квазиимпульсами p различны, то энергия, приобретённая электронами в скин-слое, оказывается рассредоточенной по интервалу значений x от δ до макс. диаметра орбиты (рис. 5). Т. к. диаметр орбиты — функция проекции импульса электрона на направление магн. поля p_H , то в результате усреднения по всем электронам выделенными оказываются электроны с экстремальными значениями $D(p_H) = D_{extr}$. В результате на расстоянии $x = D_{extr}$, где разброс диаметров электронных орбит $\Delta D \leq \delta$, происходит фокусировка эфф. электронов. Это служит причиной возникновения всплеска электрич. ВЧ-поля E , k -рый служит исходным для след. всплеска на глубине $2D_{extr}$ и т. д. (рис. 4, 5). Т. о. возникает цепочка выделенных траекторий, по k -рой эл.-магн. поле проникает на большую глубину.

При т. н. многоканальном зеркальном отражении ВЧ-поля на скин-слое в глубь образца.

Рис. 5. Перенос электронами ВЧ-поля на скин-слое в глубь образца.

вдоль поверхности, не покидая (скин-слой), то уходит на скин-слое в глубь образца (рис. 6), возникает доплит. всплески ВЧ-поля, отсутствующие в пластинах с шероховатыми поверхностями. Дальнейший

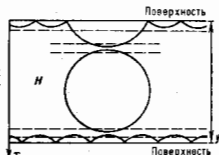


Рис. 6. Всплески ВЧ-поля при двухканальном отражении от границы.

перенос ВЧ-поля из этого всплеска в глубь металла осуществляют электроны с D_{extr} .

Т. к. $D_{extr} \propto H^{-1}$, то, изменяя поле H , можно перемещать расположение всплесков ВЧ-поля. Прозрачность тонкой пластины резко возрастает при тех значениях H , при k -рых всплеск приближается к противоположной поверхности образца. В результате прозрачности и поверхностный импеданс пластины осциллирует с изменением H (*Гантцлера эффект*).

Ширины последоват. всплесков ($\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$) и их форма зависят от l и состояния поверхности образца. Чем больше l , тем уже всплески ВЧ-поля. В пластинах с шероховатыми поверхностями по ширине всплеска можно определить длину свободного пробега электронов, формирующих всплеск. В пластинах с гладкими границами всплеск при подходе к противоположной трансформируется электронами, зеркально отражаемыми на ней. Отражённые электроны создают вблизи поверхности большой ток, ослабляющий ВЧ-поле во всплеске (рис. 6). Уменьшенный всплеск выходит на противоположную поверхность образца.

Всплеск поля формирует небольшая доля электронов (у k -рых разброс диаметров орбит $\Delta D \leq \delta$), и, как правило, поле во всплеске невелико, оно меньше поля на поверхности пластины $E(0)$: $E(D_{extr}) < E(0)$. Однако в условиях *циклотронного резонанса* возможна ситуация, когда один и те же электроны формируют и поверхностный импеданс, и всплеск ВЧ-поля. Тогда $E(D_{extr}) \approx E(0)$.

Если период волны $2\pi/\omega$ сравним или меньше времени свободного пробега электрона $\tau = l/v$, т. е. $\omega\tau \gg 1$, то возможен случай, когда за время полёта электрона сквозь скин-слое фаза ВЧ-поля многократно меняет знак. Если при этом электроны ни разу не сталкиваются с рассеивателями, то в слабом магн. поле ($r > d$) они создают слаботухающее поле, образуя осцилляции ВЧ-поля во времени в пространственные осцилляции. Это приводит к осцилл. зависимости прозрачности R тонких металлических пластин от $H^{-1/2}$ (рис. 7).

Размерный *циклотронный резонанс*. В магн. поле H , параллельном границам пластины, при $D_{extr} < d$ *циклотронный резонанс* имеет такой же характер, как и в массивных образцах, т. е. наблюдается резонансное уменьшение активной R и реактивной X составляющих поверхностного импеданса Z пластины. Если же траектория резонирующих электронов не помещается в сечении образца, т. е. $D_{extr} > d$, то происходит

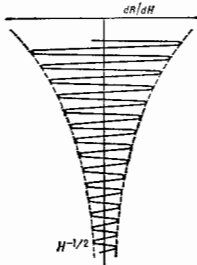


Рис. 7.

«отсекание» частот, соответствующих полю $H_{от}$, а вместо них появляется новая резонансная частота, кратная циклотронной частоте электрона Ω (рис. 8): $\omega = n\Omega = \frac{neH}{mc}$ (n — целое число, m — эффективная масса

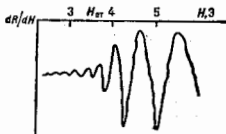


Рис. 8. Спектр циклотронного резонанса в тонком монокристалле Ni ; при $H < H_{от}$ наблюдается резонанс на неэкстремальных орбитах.

электрона). Этой частоте соответствует диаметр орбиты электрона $D = d$. Диаметр орбиты D связан с диаметром соответствующего сечения поверхности Ферми D_p соотношением $D = cD_p/eH$. Поэтому новая частота определяется условием $d = cD_p/eH$ или $Hd = cD_p/e$. Изменяя зависимость поверхностного иппеданса Z от H при разл. d , но при $Hd = \text{const}$, можно построить семейство кривых $Z(d)$, когда D_p фиксировано. Соответствующие резонансные пики Z позволяют определить m . Изменяя Hd , можно определить эфф. массы электронов на всей поверхности Ферми.

В пластине с достаточно гладкими гранями циклотронный резонанс возможен в слабых магн. полях, удовлетворяющих условию $l \ll r \ll D/d$. При этом электроны периодически возвращаются в скин-слой за счёт зеркальных отражений от противоположной грани, а роль магн. поля сводится лишь к искривлению траекторий резонансных электронов. Условие резонанса имеет вид $\omega = 2\pi lT^{-1}$, где T — период движения зеркально отражённых электронов.

Размерный циклотронный резонанс наблюдается и при $D_{extr} < d$. Он обусловлен электронами, взаимодействующими с ВЧ-полем во всплеске. Роль толщины d в этом случае играет величина $d - D_{extr} \cdot N$, где N — число всплесков в пластине. Резонанс наступает, когда ω кратна частоте обращения электронов с диаметром орбиты $d - D_{extr} \cdot N$. Обратное влияние всплесков на поле в скин-слое приводит к резонансной дробке к иппедансу, зависящей от параметров зеркальности обеих граней.

Размерный эффект при отражении Андреева. При отражении электронов проводимости межфазной границей нормальный металл N (или полупроводник) — сверхпроводник S изменяется знак их скорости: $v \rightarrow -v$ (см. *Отражение андреевское*). Если слой нормального металла толщиной d помещён на сверхпроводящую подложку, то в магн. поле отсекание частот циклотронного резонанса наступает, когда радиус орбиты резонансных электронов $r > d$.

При $r < d < 2r$ траектория электрона после отражения Андреева дополняет его траекторию до полной орбиты в массивном образце (рис. 9). Т. о., отражение не меняет период движения и, следовательно, резонансную частоту. При $r > d$ эти частоты отсечены из-за отражения электронов границей металл — вакуум. Вместо них появляются частоты, кратные частоте обращения электронов, диаметр орбиты к-рых равен $2d$.

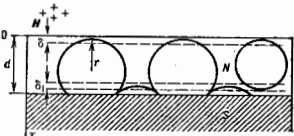


Рис. 9. Траектории носителей заряда в магнитном поле, параллельном слою нормального металла, испытывающих отражение Андреева от сверхпроводящей подложки.

Отражённые $N-S$ -границей электроны создают всплеск ВЧ-поля на нек-ром расстоянии от межфазной границы. Когда всплеск с уменьшением H приближается к скин-слою, происходит резкое изменение поверхностного иппеданса пластины.

Размерные магнитоакустич. явления также более информативны, чем их аналоги в массивных образцах, т. н. *геометрические осцилляции*, и *византные квантовые осцилляции*, магнитоакустич. резонансы (см. *Акусто-электронное взаимодействие*).

Лит.: Андреев А. Ф., Теплопроводность промежуточного состояния сверхпроводников, *ЖЭТФ*, 1964, т. 46, с. 1823; Козиник Ю. Ф., Физика металлических пленок, М., 1978; Гоффельд В. М., Кириченко О. В., Песчанский В. Г., О затухании ультразвука в тонких слоях металла в магнитном поле, *ЖЭТФ*, 1960, т. 79, с. 538; Рашбаляк У. Г., Kinetic Size Effects in Metals in a Magnetic Field, *Sov. Sci. Rev. A. Phys.*, 1992, v. 16, p. 1—112; Коган Е. М., Устинов В. В., Электропроводность тонких металлических пленок при маломгнетном векторно-фононном рассеянии, «Физ. металл. и металловедение», 1982, т. 54, с. 258; Электроны проводимости, под ред. М. И. Каганова, В. С. Зельманова, М., 1985. В. Г. Песчанский.

РАЗМЕЩЕНИЕ (перемещение) в фазовом пространстве — свойство потока траекторий консервативной динамической системы, достаточное для перехода этой системы в процессе её временной эволюции к стохастич. поведению.

Поток траекторий динамической системы не уходит на бесконечность, и движение происходит в нек-рой ограниченной области D объёмом V_D фазового пространства, тогда формально P выражается существованием предела

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mu(A_t | B) = \mu(A)(B), \quad (1)$$

где A, B — две произвольные (как правило, малые) области, принадлежащие D , $\mu(A), \mu(B)$ — их меры (в простейшем случае — относ. объёмы этих областей). Обычно область B предполагается фиксированной, а область A эволюционирует во времени в соответствии с *Гамильтоновыми уравнениями*, A_t — значение A в момент времени t , область $A_t | B$ является пересечением областей A_t и B . Для консервативных систем $\mu(A_t) = \mu(A)$ (т. н. *инвариантность меры*, см. также *Луэвля-теорема*). P означает, что независимо от размеров,

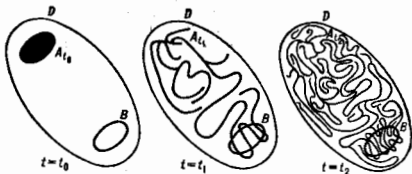


Рис. 1. Эволюция области A и случае размешивания.

формы и взаимного расположения областей A и B во времени достаточно длительного времени элемент области A могут быть обнаружены в любой сколь угодно малой окрестности произвольной точки области D (рис. 1).

Термин « P » введён Дж. У. Гиббсом (J. W. Gibbs, 1902) по аналогии между движением системы взаимодействующих частиц в фазовом пространстве и перемешиванием жидкости («растворителя» и «красителя»). При этом жидкости рассматриваются как непрерывные среды, неразрывные и несжимаемые; реальные молекулярная структура и диффузия не учитываются. Если в нач. момент жидкости не были перемешаны, то при любом возмущении (встряхивание, вальтование и др.) такая система с течением времени станет практически однородно перемешанной (рис. 2).

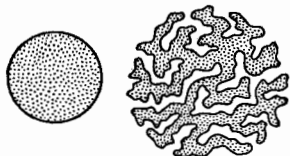


Рис. 2. Расплывание капли при размещивании.

Доказано, что из Р. следует эргодичность системы (см. *Эргодическая гипотеза*), однако обратное утверждение неверно. Эргодичность обеспечивает допустимость использования статистических средних лишь в смысле среднего по времени, тогда как при Р. это справедливо и асимптотически. Эргодичность (без Р.) соответствует регулярно квазипериодическому заполнению фазового пространства траекториями, Р. — хаотическому (рис. 3).

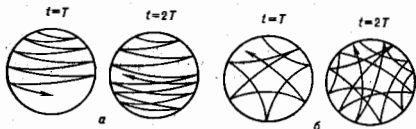


Рис. 3. Различие между эргодическим движением без размещивания (а) и движением с размещиванием (б).

Выполнение условия (1) строго доказано лишь для неких динамич. систем с малым числом степеней свободы. Предполагается, что Р. характерно для мн. систем и отражает общее свойство неустойчивости (разбегания) фазовых траекторий по отношению к малым возмущениям нач. условий. Р. обуславливает непредсказуемость и необратимость поведения динамич. системы (*хаос динамический*). Р. соответствует предельно о характере движений в сложной динамич. системе, требующем перехода к статистич. описанию, но не даёт строгого обоснования применимости методов статистич. механики.

Важнейшим следствием существования Р. является распределение временных корреляций, т. е. выполнение условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle f(A_t), g(A) \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle = 0, \quad (2)$$

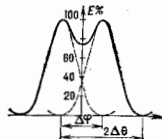
где $\langle f(A_t), g(A) \rangle$ — корреляц. ф-ция динамич. переменных f и g , $\langle f \rangle$ и $\langle g \rangle$ — их статистические средние. Свойство (2) означает, что система, обладающая Р., со временем «забывает» о своих нач. условиях и корреляциях.

Лит.: Гиббс Дж., Термодинамика. Статистическая механика, пер. с англ., М., 1962, гл. 12; Крылов И. С., Работы по обоснованию статистической физики, М.—Л., 1960; Вилерс С. К. Р., Равновесия и неравновесия статистическая механика, пер. с англ., т. 2, приложение: Эргодическая проблема, М., 1978; Заславицкий Г. М., Стохастичность динамических систем, М., 1984, гл. 1; Лоскутов А. Ю., Митчелл Д. А. С., Введение в синергетику, М., 1990. Д. Н. Суборов. **РАЗНОСТНЫЙ ТОН — комбинационный тон** с частотой $\omega_1 - \omega_2$, возникающий в нелинейной акустич. системе при воздействии на неё двух звуковых колебаний с частотами ω_1 и ω_2 . Особое значение Р. т. заключается в том, что он может оказаться в слышимом диапазоне частот, даже если ω_1 и ω_2 — неслышимые частоты, а это позволяет регистрировать сигналы с частотами ω_1 и ω_2 . **РАЗНОСТЬ ХОДА** лучей (в оптике) — разность оптических длин путей двух световых лучей, имеющих

общие начальную и конечную точки. Понятие Р. х. лучей играет осн. роль в описании *интерференции света* и *дифракции света*. Расчёты распределения световой энергии в оптич. системах основаны на вычислении Р. х. проходящих через них лучей (или пучков лучей). Понятием Р. х. пользуются при описании волновых явлений реал. природы.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (разрешающая сила) оптических приборов — величина, характеризующая способность этих приборов давать раздельное изображение двух близких друг к другу точек объекта. Наименьшее линейное (или угловое) расстояние между двумя точками, начиная с к-рого их изображения сливаются и перестают быть различимыми, наз. линейным (или угловым) пределом разрешения и я. Обратная ему величина служит количественной мерой Р. с. оптич. приборов. Идеальное изображение точки как элемента предмета может быть получено от волновой сферич. поверхности. Реальные оптич. системы имеют входные и выходные зрачки (см. *Диафрагма*) конечных размеров, ограничивающие волновую поверхность. Благодаря *дифракции света*, даже в отсутствие *аббераций оптических систем* и ошибок изготовления, оптич. система изображает точку в монохроматич. свете в виде светлого пятна, окружённого поперечно темными и светлыми кольцами. Пользуясь теорией дифракции, можно вычислить наим. расстояние, разрешаемое оптич. системой, если известно, при каких распределениях освещённости приёмник (глаз, фотослой) воспринимает изображение раздельно. В соответствии с условием, введённым Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh, 1879), изображения двух точек можно видеть раздельно, если центр дифракц. пятна каждого из них пересекается с краем первого тёмного кольца другого (рис.).

Распределение освещённости E в изображении двух точечных источников света, расположенных так, что угловое расстояние между максимумами освещённости $\Delta\theta$ равно угловому радиусу центрального дифракционного пятна $\Delta\theta$ ($\Delta\theta = \Delta\theta$ — условие Рэлея).



Если точки предмета самосветящиеся и излучают некогерентные лучи, выполнение критерия Рэлея соответствует тому, что наим. освещённость между изображениями разрешаемых точек составит 74% от освещённости в центре пятна, а угл. расстояние между центрами дифракц. пятен (максимумами освещённости) определит выражением $\Delta\theta = 1,22\lambda/D$, где λ — длина волны света, D — диаметр входного зрачка оптич. системы. Если оптич. система имеет фокусное расстояние f , то линейная величина предела разрешения $\delta = 1,22\lambda f/D$. Предел разрешения телескопов и зрительных труб выражают в угл. секундах и определяют по ф-ле $\delta = 140/D$ (при $\lambda = 560$ нм и D в мм) (о Р. с. микроскопов см. в ст. *Микроскоп*). Приведённые ф-лы справедливы для точек, падающих на оси идеальных оптич. приборов. Наличие аббераций и ошибок изготовления снижает Р. с. реальных оптич. систем. Р. с. реальной оптич. системы падает также при переходе от центра поля зрения к его краям. Р. с. оптич. прибора $R_{оп}$, включающего комбинацию оптич. системы и приёмника (фотослой, катод *электронно-оптического преобразователя* и др.), связана с Р. с. оптич. системы $R_{ос}$ и приёмника $R_{п}$ приближённой ф-лой

$$R_{оп}^{-1} = R_{ос}^{-1} + R_{п}^{-1},$$

из к-рой следует, что целесообразно применение лишь таких сочетаний, когда $R_{ос}$ и $R_{п}$ одного порядка. Р. с. прибора может быть оценена по его *аппаратной функ-*

чем: чем шире аппаратная ф-ция, тем хуже разрешение δ (меньше H).

Для определения Р. с. оптич. приборов существуют *матри* — прозрачные или непрозрачные пластинки с нанесенными на них стандартным рисунком.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 3 изд., ч. 1—2 М.—Л., 1948—52; Лаврентьев Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976.

РАЗРЕШЕННЫЕ ЛИНИИ — спектральные линии, возникающие при излучательных квантовых переходах, для к-рых выполняется *отбора правила* для электр. дипольных переходов (в отличие от *запрещенных* линий).

РАЗРЫВНЫЕ КОЛЕБАНИЯ — колебания, при к-рых наряду со сравнительно медленными изменениями величины, характеризующих состояние колебат. системы, в нек-рые моменты происходит столь быстрые изменения этих величин, что их можно рассматривать как скачки, а весь колебат. процесс в целом — как последовательность медленных изменений состояния системы, начинающихся и кончающихся мгновенным его изменением (скачками или разрывами). *Релаксационные колебания* часто рассматриваются как Р. к.

РАЗРЫВЫ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ — тонкие переходные области, в к-рых происходит резкое изменение (скачок) магнитогидродинамич. (МГД-) параметров (давления, энтропии, плотности, скорости течения, магн. поля) или их производных. Р. м. возникают при столкновении двух потоков, обтекания тел (напр., обтекания планет солнечным ветром), разрывах (вспышках новых и сверхновых звезд), при сжатии газа поршнем, внезапном включении ал.-магн. поля, изменении (исчезновении) начальных или граничных условий и т. д. Р. м. распространяются в идеальном газе (жидкости, плазме) с высокой (строго говоря, бесконечной) скоростью, проводимостью в присутствии магн. поля. Если пренебречь эффектами неидеальности вещества (вязкостью, теплопроводностью, джоулевым нагревом), то толщина переходной области равна нулю, т. е. Р. м. сосредоточены на поверхности.

Различают слабые и сильные Р. м. Слабые м. наз. разрывы, на поверхности к-рого имеет место скачок к-л. производных МГД-параметров как ф-ий координат при непрерывности самих параметров. Поверхности, на к-рых возможен скачок Р. м., являются характерист. поверхностями ур-ний идеальной *магнитной гидродинамики*. Существует 7 типов слабых Р. м.: зонтичный, 2 альвовеских, 2 быстрых и 2 медленных магнитозвуковых. Слабые Р. м. движутся относительно среды со скоростью соответствующих линейных волн.

Р. м. наз. сильными, если на его поверхности имеет место скачок одного или всех МГД-параметров. Сильный Р. м. может образоваться при пересечении слабых разрывов одного типа. Граничные условия на поверхности сильного Р. м., связывающие значения МГД-параметров по разные стороны разрыва, получаются из законов сохранения массы, импульса и энергии и ур-ний Максвелла в интегральной форме. В системе отсчета, где сильный Р. м. покоится, они в изотропном случае ($p_1 = p_2$) имеют вид:

$$\{H_n\}=0, \{v_n\}=0, H_n(v_n) = (H \cdot v_n),$$

$$\left\{p + \rho v_n^2 + \frac{H^2}{8\pi}\right\}=0, \left\{\rho v_n v_n - \frac{H_n}{4\pi} H_n\right\}=0, \quad (1)$$

$$\left\{\rho v_n \left(\mathcal{E} + \frac{1}{2} v^2\right) + p v_n + \frac{H^2}{4\pi} v_n - \frac{H_n}{4\pi} H \cdot v_n\right\}=0.$$

Здесь p , ρ и \mathcal{E} — соответственно давление, плотность и уд. внутр. энергия вещества; v_n , v и H_n , H — нормальная и тангенциальная (относительно поверхности разрыва) компоненты соответственно скорости вещества и напряженности магн. поля; скобка $\{f\}$ обозначает

скачок параметра f при переходе через поверхность разрыва, т. е. разность $(f_2 - f_1)$ значений этого параметра за фронтом разрыва f_2 и перед ним f_1 .

Различают 4 типа сильных Р. м.: тангенциальный, контактный, альвовеский и ударные волны. Для тангенциального Р. м. разрыва поток вещества через поверхность разрыва отсутствует ($v_n = 0$), а магн. поле параллельно поверхности разрыва ($H_n = 0$). На тангенциальном Р. м. плотность ρ и тангенциальная скорость v_t имеют скачки произвольной величины, а скачки давления p и магн. поля H связаны соотношением:

$$\left\{p + \frac{H^2}{8\pi}\right\}=0. \quad (2)$$

В анизотропном случае, когда $p_t \neq p_l$, скачок произвольной величины может иметь продольное давление p_t , а скачки поперечного давления p_l в магн. поля H_t связаны соотношением (2).

Тангенциальный разрывом является поверхность раздела двух жидкостей с разл. термодинамич. параметрами, движущимися относительно друг друга с нек-рой скоростью, параллельной границе раздела. Примером тангенциального Р. м. служит магнитолауза как граница раздела между магнитосферой и солнечным ветром. На тангенциальном разрыве обычно развивается неустойчивость Кельвина — Гельмгольца с *инкрементом*

$$\gamma = \frac{k}{2} \left[(v_1 - v_2)^2 - \frac{H^2}{4\pi} \right]^{1/2}.$$

Она может быть застabilизирована достаточно сильным магн. полем $H^2 > 4\pi(v_1 - v_2)^2$.

Контактный разрыв в покое находится относительно среды ($v_n = 0$), однако магн. поле имеет нормальную компоненту ($H_n \neq 0$). На поверхности контактного Р. м. непрерывны давление p , магн. поле H , скорость v_t , а плотность ρ и др. термодинамич. параметры могут испытывать произвольные скачки. В анизотропном случае, $p_t \neq p_l$, давление и тангенциальная компонента магн. поля могут иметь на контактом разрыве скачки, удовлетворяющие соотношениям:

$$\left\{H_n + \frac{4\pi(p_l - p_t)}{H^2} H_n\right\}=0,$$

$$\left\{p_l + \frac{H^2}{8\pi} + \frac{H_n^2(p_l - p_t)}{H^2}\right\}=0.$$

На альвовеском (вращательном) разрыве плотность среды не меняется, $\{p\} = 0$, однако имеется поток вещества через поверхность разрыва ($v_n \neq 0$). Альвовеский Р. м. движется относительно этой поверхности вперед и назад ней со скоростью альвовеской волны $v_a = H/\sqrt{4\pi\rho}$. На альвовеском разрыве полная напряженность магн. поля $H = (H_n^2 + H_t^2)^{1/2}$ непрерывна, однако сам вектор H поворачивается вокруг нормали к поверхности разрыва на нек-рый угол. Термодинамич. параметры при переходе через альвовеский разрыв непрерывны, $\{s\} = 0$, $\{p\} = 0$, а скачки тангенциальных компонент скорости и магн. поля связаны ф-лой:

$$v_n = -\frac{(H_t)}{\sqrt{4\pi\rho}} \frac{\operatorname{sgn} H_n}{\operatorname{sgn} v_n}.$$

В случае анизотропного давления $p_t \neq p_l$ на альвовеском (вращательном) разрыве плотность и внутр. энергия, а также магн. поле могут тоже испытывать скачки, к-рые связаны соотношениями:

$$\{\mathcal{E}\} = -\left\{\frac{H^2}{8\pi\rho} + \frac{p_l - p_t}{2\rho}\right\}, \left\{p + \frac{4\pi\rho}{H^2} (p_l - p_t)\right\}=0.$$

Разрывы, движущиеся относительно среды ($v_{\text{др}} \neq 0$), на k -рых плотность среды испытывает скачок, наз. *ударными волнами*. На ударных волнах возрастает энтропия, $s_2 - s_1 = \{s\} > 0$, а также практически для всех видов веществ растут давление и плотность:

$$\{p\} > 0, \{\rho\} > 0.$$

Ударные волны плоско поляризованы, т. е. векторы H_1 , H_2 и нормаль к поверхности разрыва лежат в одной плоскости. Скорость ударной волны относительно вещества перед ней зависит от её амплитуды, т. е. от величины скачка k -л. МГД-параметра, напр. $\{p\}$. При стремлении амплитуды ударной волны к нулю её скорость стремится к скорости линейных *магнитозвуковых волн*, быстрой v_f или медленной v_g . Зависимость между значениями термодинамич. параметров перед волной и позади неё науд. ударной адиабатой или адиабатой Гюгонио. Различают параллельные, перпендикулярные и косые ударные волны.

Эволюционность и устойчивость разрывов магнитогидродинамических. Р. м., устойчивые относительно распада на неск. разрывов или нестационарных течений, наз. *эволюционными*. Любое бесконечно малое возмущение эволюц. разрыва приводит (по крайней мере на достаточно малых промежуточных временах) к малым изменениям МГД-параметров разрыва. Возмущения эволюц. разрыва могут возрастать во времени по экспоненци. закону (как взрыв с положит. инкрементом γ), что свидетельствует о неустойчивости такого разрыва, однако в течение времени $t \leq 1/\gamma$ возмущение остается малым. Введение понятия эволюционности Р. м. связано с возможностью построения нестационарных решений с заданными нач. условиями. Если линеаризованная задача о взаимодействии малых возмущений с разрывом не имеет решения либо имеет не единств. решение, что указывает на неправомерность исходного предположения о малости амплитуд возмущений в течение малого, но конечного времени, то разрыв наз. *неэволюционным*. Незволуч. разрыв в течение короткого времени (в модели идеальной магн. гидродинамики — мгновенно) распадается на неск. устойчивых разрывов или может перейти в нестационарное течение. Альбеновские, тангенциальные и контактные Р. м. относятся к классу эволюционных. Для ударных волн условие эволюционности накладывает ограничения на скорость разрыва относительно среды. В частности, скорость быстрой ударной волны относительно среды перед ней должна быть больше скорости быстрой магнитозвуковой волны в среде v_{f1} , а скорость относительно среды за ней — меньше скорости быстрой магнитозвуковой волны v_{fg} .

При падении волн на сильный разрыв коэф. отражения может превышать единицу, т. е. волна усиливается в процессе отражения.

Структура разрывов. При учёте неидеальности вещества (вязкости, теплопроводности, джоулева нагрева) поверхность сильного разрыва размывается в узкий переходный слой, в k -ром МГД-параметры изменяются быстро, но непрерывно. Характер изменения параметров среды в переходной области наз. *структурой разрыва*. Толщина переходной области для слабой ударной волны часто превышает длину свободного пробега частиц. Это позволяет использовать ур-ния магн. гидродинамики с учётом малых диссипативных факторов для исследования структуры разрыва, k -рая часто описывается монотонной ϕ -цней. В разреженной плазме шарные кулоновские столкновения могут быть весьма редкими и структура разрыва будет определяться коллективными процессами, а толщина переходной зоны может быть существенно меньше длины свободного пробега (напр., *бестокмоинительные ударные волны*).

Лит.: Кудряковский А. Г., Дюбинов Г. А., *Магнитная гидродинамика*, М., 1962; *Plasma Electrodynamics*, т. 2, Окл., 1975; Баранов Б. Б., Краснобаев И. В., *Гидродинамическая теория космической физики*, М., 1977; Арцимович Л. А., Сагдеев Р. З., *Физика плазмы для физи-*

ков, М., 1979; Половин Р. В., Демухин Я. П., *Основа магнитной гидродинамики*, М., 1987.

РАЗРЫДНАЯ ПЛАЗМА — то же, что *низкотемпературная плазма*.

РАЗРЫДНИКИ — газоразрядные приборы для замыкания и размыкания электрич. цепи; содержат два или более электродов. Электрич. разряд, замыкающий или размыкающий электрич. цепь, в и-рую включён Р.; зажигается или гасится при изменении напряжения U , приложенного к электродам. Напряжение зажигания (или пробоя $U_{\text{пр}}$) определяется кривой Пауэна — зависимостью $U_{\text{пр}}$ от произведения давления p на расстояние между электродами d (см. *Пауэна закон*). В зависимости от сочетания этих величин, а также параметров электрич. цепи в Р. могут иметь место разл. формы разряда: коронный, тлеющий, искровой, дуговой и др. или их смешанные формы (см. *Электрические разряды в газах*). Многообразие форм разряда и их параметров определяет применение Р. в электротехнике, радиотехнике, радиоэлектронике, автоматике — для защиты электрич. цепей и приборов от перенапряжений (и k -ровые Р.), для коммутации цепей в импульсной миллиамперсекундной радиотехнике, для передачи энергии в нагарку от ёмкости накопителей энергии (газо-и-ые Р.), Р. используются для измерения высокого напряжения (измерительные Р.), для индикации вакуума (по характеру свечения определяют степень разрежения). В аксеприм. физике управляемые Р. служат для включения импульсных устройств с точностью по времени до десятков нс (напр., в искровой камере, ячейке Керра и т. д.).

Лит.: Калашников А. М., Слудский В. З., *Электронные приборы и импульсная техника*, М., 1962.

РАЗРЫДНЫЕ ТРУБКИ (трубки Коверси, гомоскопические трубки) — управляемые газоразрядные координатные детекторы ионизирующих частиц. Представляют собой совокупность тонкостенных стеклянных или пластмассовых трубок (изредка полых стеклянных шариков) diam. 3—20 мм и длиной ≥ 1 м (иногда профилированных полипропиленовых пластин с каналами прямоуг. сечения), наполненных инертным газом (обычно Ne, смесь Ne с He или Ne с добавкой $\sim 0.2\%$ Ar) под давлением 0.5—3 атм и помещённых между плоскими электродами. Когда через Р. проходит ионизирующая частица, то по сигналу управляющих детекторов на электроды подается высокочастотный импульс (длительностью 2—4 мкс и запаздыванием ≤ 1 мкс), создающий в межэлектродном пространстве электрич. поле напряженностью до 8 кВ/см.атм. При этом электроны, освобождающиеся в результате ионизации газа Р. т. ионизирующей частицей, и фотоэлектроны, выбитые из стенок Р. т. излучением возбуждённых той же частицей атомов газа, ускоряются электрич. полем и иницируют внутри Р. т. импульсный разряд, k -рый захватывает весь её объём. Этот разряд фотографируют через прозрачный торец трубки или регистрируют в виде электрич. сигнала, используя фотосоответвление, фотодиод, а также с помощью введённого внутрь Р. т. электрода (или внеш. электрода, чувствительного к эл.-магн. полю, создаваемому разрядом).

Поскольку разряд распространяется по всей длине Р. т., она является одномомерным детектором. Для пространственной локализации траекторий частиц используют многослойные системы уложенных крест-накрест Р. т. (разрядные камеры) площадью до неск. десятков м^2 , содержащие десятки и сотни тысяч Р. т. Подобные камеры, просвеченные блоками плотного вещества, представляют собой разновидность ионизационного calorimetpa, где энергия частицы измеряется по общему числу зажигания Р. т.

Ост. характеристики Р. т. как детектора частиц — эффективность регистрации, пространственное (координатное) разрешение, время чувствительности и «мёртвое» время, долговечность. Эффективность Р. т. зависит от её диаметра, состава и давления газа, ионизирующей

способности частицы, параметр высоковольтного импульса и обычно составляет 60—100%. При этом вероятность лонной вспышки не превышает 1%. Координатное разрешение Р. т. определяется её радиусом, однако если частица пересекает большое число Р. т., точность восстановления траектории оказывается значительно выше. Время чувствительности, определяемое как время задержки импульса высокого напряжения, при к-ром эффективность Р. т. падает вдвое, составляет 30—40 мкс, но может быть сокращено до ~1 мкс введением в газ электротриггера, добавок (O_2 , SF_6 и т. п.) — в кол-ве менее 0,4% или применением переменного опчиющего элктрич. поля напряжённостью до 10 В/см. «Мёртвое» время Р. т. зависит от скорости процессов деионизации и деаэобуждения газа после разряда и обычно составляет 0,1—1 с, но может быть снижено до 10 мс теми же методами, что и время чувствительности. Для предотвращения экранирования внеш. элктрич. поля полем статич. заряда, осевшего на внутр. стенках Р. т., материал стенок должен иметь не слишком большое объёмное сопротивление (ниже 10^{12} Ом·см). Стеклянная Р. т. выдерживает более 1,6 млн. вспышек без изменения характеристик.

Деионизация, простота эксплуатации, долговрем. стабильность Р. т. обусловили их широкое применение в наземных и подземных исследованиях космических лучей, при поисках распада протона, в нейтринных экспериментах на ускорителях, где необходимы детекторы большой площади, а потоки частиц сравнительно невелики. Однако Р. т. вытесняются *статическими трубками* (дрейфовыми), обладающими лучшими временными и координатными параметрами. Зависимость эффективности Р. т. от ионизир. способности частиц использовалась при поисках свободных кварков — частиц с зарядом $1/3$ заряда электрона в составе космич. лучей.

Лит.: Некрасов камера, М., 1967; Солнцев М. В. Г. о с. G. Flash-tube hodoscope chambers, «Ann. Rev. Nucl. Sci.», 1973, т. 23, с. 75. Г. И. Мерлов.

РАЗРЫДЫ В ГАЗАХ — то же, что *электрические разряды в газах*.

РАЗУПРОЧНЕНИЕ — процесс понижения прочности и повышения пластичности материалов, предварительного упрочнённых в результате наклёта, термич. обработки (для сталей — закалка с низкотемпературным отпуском, а для сплавов с ограниченной растворимостью, зависящей от темп-ры, — дисперсионное твердение) или облучения частицами с высокой энергией (нейтронами, α -лучами, электронами). Упрочнённое состояние (см. Упрочнение) связано с наличием структурных несовершенств разл. рода и масштаба и является метастабильным. Поэтому при нагреве или в случае относительно легкотоплавких металлов и сплавов, при длительном выдерживании при комнатной температуре происходит Р. т., к-рое является средством огрубления микро- и субмикроструктуры упрочнённого материала (видоизменения дислокац. структуры). Р. при нагреве после наклёта происходит уже при отжыке, когда имеют место частичная аннигиляция точечных дефектов и дислокаций, а также их перераспределение, и полностью завершается после *рекристаллизации*, приводящей к образованию новых зёрен, плотности дислокаций в к-рых значительно

ниже, чем в деформированных. Степень Р. зависит от темп-ры и времени отжига (рис. 1).

Легирующие элементы повышают темп-ру Р. Напр., предел текучести железа при нагреве после деформации прокаткой до 80% начинает снижаться уже при 200 °С, а введение в него 0,8% нобия повышает темп-ру начала Р. до 600 °С.

Р. при нагреве после дисперсионного твердения (рис. 2) связано с нарушением сопряжения (когерентности) между кристалл. решётками частиц выделяющейся фазы и основного *твердого раствора*, коагуляцией указанных частиц (увеличением ср. расстояния

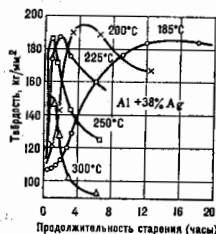


Рис. 2. Изменение твердости сплава Al + 38% Ag при нагреве после закалики.

между ними), обеднением твердого раствора легирующими элементами и отжыком или рекристаллизацией твердого раствора. При достаточном высокому нагреве Р. может быть обусловлено обратным растворением вышедших частиц в твердом растворе. Упр. роста каждого из перечисленных процессов в Р. зависит от состава сплава и режима термич. обработки. Р. при нагреве облучённых материалов обусловлено перераспределением точечных дефектов, их частичной аннигиляцией, изменением взаимодействия с дислокациями, а также с перераспределением дислокаций, закреплённых точечными дефектами и образовавшихся в результате скопления точечных дефектов. Р. может иметь место также непосредственно в процессе пластич. деформации в тех случаях, когда происходит поперечное скольжение и перераспределение дислокаций.

Лит.: Горелик С. С. Рекристаллизация металлов и сплавов, 2 изд., М., 1978; Рекристаллизация металлических материалов, Сб., под ред. Ф. Хекстера, пер. с англ., М., 1982. В. М. Розенберг.

РАКА КОЭФФИЦИЕНТЫ — в квантовой механике характеризуют сложение трёх (и более) угл. моментов, а также *изотопических спинов* и др. аналогичных величин, связанных с группой трёхмерных вращений (см. *Квантовое сложение моментов*). Введены Дж. Рака (G. Racah, 1942) при развитии теории спектров сложных атомов. Широко применяются в раал. приложённых квантовой механики, а также в задачах теории представлений групп $SU(2)$ и $SO(3)$.

В результате сложения трёх моментов j_1, j_2 и j_3 полный момент j можно получить неск. способами (разл. схемы связи):

$$j_1 + j_2 = j_{12}, \quad j_{12} + j_3 = j; \quad (1a)$$

$$j_2 + j_3 = j_{23}, \quad j_1 + j_{23} = j; \quad (1b)$$

$$j_1 + j_3 = j_{13}, \quad j_{13} + j_2 = j. \quad (1в)$$

Вектор состояния, соответствующий схеме связи (1a), обычно обозначают как $|j_1 j_2 (j_{12}) j m\rangle$. Он является собств. вектором для операторов j^2, j_z, j_1^2, j_2^2 и j_3^2 , причём собств. значения двух последних операторов равны $j(j+1)$ и $m, -j \leq m \leq j$. Приведём его явное выражение через собств. векторы $|j_i m_i\rangle$ трёх складываемых моментов:

$$|j_1 j_2 (j_{12}) j m\rangle = \sum_{m_1 m_2 m_3} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{j_{12} m_{12}} C_{j_{12} m_{12} j_3 m_3}^{j m} \times \\ \times |j_1 m_1 j_2 m_2 (j_{12}) m_{12}\rangle. \quad (2)$$

Здесь $m_{12} = m_1 + m_2, m = m_{12} + m_3$, а C — *Клебиа — Гордана коэффициенты*.

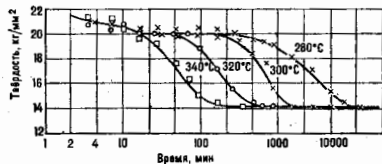


Рис. 1. Изменение твердости алюминия, деформированного растяжением до 20%, со временем при различных температурах.

Аналогично (2), схемам связей (16, 17) отвечают векторы состояния $|j_1 j_2 (j_{23}) j m\rangle$ и $|j_1 j_2 (j_1) j_2 j m\rangle$.

Р. к. характеризуют соотношения между состояниями, отвечающими указанным реал. схемам связей. Переход от одной схемы связи к другой осуществляется унитарным преобразованием (матрицей), элементы к-рого отличаются от Р. к. $W(j_1 j_2 j_3; j_{12} j_{23})$ только нормировочными множителями:

$$|j_1 j_2 (j_{23}) j m\rangle = \sum_{j_{12}} U(j_{12} j_{23}) |j_1 j_2 (j_{12}) j_3 j m\rangle, \\ U(j_{12} j_{23}) = [(2j_{12}+1)(2j_{23}+1)]^{1/2} W(j_1 j_2 j_3; j_{12} j_{23}). \quad (3)$$

Отсюда следует, что Р. к. могут быть выражены через суммы от произведения четырех коэффициентов Клебша — Гордана. Поэтому Р. к. всегда вещественны и отличаются от нуля только в том случае, когда для каждой из трех моментов $(j_1, j_2, j_{12}), (j_2, j_3, j_{23}), (j_{12}, j_3, j)$ и (j_1, j_{23}, j) выполнено условие треугольника (т. е., напр., $|j_1 - j_2| \leq j_{12} \leq j_1 + j_2$ и т. д.).

Вместо Р. к. часто используют *Выскера 6j-символов*, к-рые отличаются от Р. к. выбором фазового множителя:

$$\left\{ \begin{matrix} j_1 j_2 j_3 \\ j_{12} j_{23} \end{matrix} \right\} = (-1)^{j_1 + j_2 + j_3} W(j_1 j_2 j_3; j_{12} j_{23}). \quad (4)$$

Р. к. обладают многочисл. свойствами симметрии, напр.,

$$W(abcd; ef) = W(edab; ef) = W(acbd; fe) = \\ = (-1)^{b+c-e-f} W(aef; bc) = (-1)^{a+d-e-f} W(efc; ad) \quad (5)$$

(полный список соотношений симметрии см. в [1—3]). Имеются также рекуррентные соотношения, связывающие между собой Р. к., в к-рых индексы изменяются на $1/2$ или 1.

Общие ф-лы для Р. к., справедливые при произвольных значениях моментов, чрезвычайно громоздки и мало пригодны для вычислений. Однако в тех случаях, когда один из моментов (напр., j_3) велик, Р. к. нетрудно подсчитать по сравнительно простым алгебраич. ф-лам. Простейшие из них имеют вид

$$W(j_1 j_2 j_0; j_3) = [(2j_2+1)(2j_1+1)]^{-1/2}, \\ W(j_1 j_2 j_0; j_3) = [(2j_2+1)(2j_1+1)]^{-1/2} = \\ = \left[\frac{(j_1+j_2+j_3+1/2)(j_1-j_2+j_3+1/2)}{j(2j+1)(j_2+1)(2j_2+1)} \right]^{1/2}, \dots$$

(табл. таких ф-л вплоть до $j_3 = 4$ см. в [1]). Имеются также численные табл. Р. к. и 6j-символов для конкретных (и не очень больших, $j_i \leq 3$) значений моментов [1, 2]. Подробное изложение теории Р. к., основанное на методах теории групп, содержится в [3].

Обобщением Р. к. являются 9j-символы, или коэф. Фану (к-рые определяются как коэф. преобразования между реал. схемами сложения четырех моментов), и в общем случае 3nj-символы [1, 3]. Для упрощения громоздких вычислений в задачах сложения большого числа моментов можно использовать спец. диаграммную технику [1, 3].

Лит.: 1) Варшавский Д. А., Москалев А. Н., Херсонский В. К., Квантовая теория углового момента. Л., 1975; 2) Юдас А. П., Бандвайтис А. А., Теория момента количества движения в квантовой механике, Вильнюс, 1977; 3) Бадемкар Л., Лаури Дж., Угловой момент и квантовая физика, пер. с англ., т. 1—2, М., 1984. В. С. Попов.

РАМАНА ЭФФЕКТ (комбинационное рассеяние света) — рассеяние света веществом, сопровождающееся изменением его длины волны, к-рое связано с колебаниями и вращениями молекул вещества. Открыт в 1928 Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом на кристаллах в Ч. В. Раманом (С. В. Раман) и К. С. Кришнаном (K. S. Krishnan) на жидкостях. Термин «Р. э.» распространен в заруб. литературе. Подробнее см. *Комбинационное рассеяние света*.

РАМЗАУЭРА ЭФФЕКТ — аномальное (с позиций классич. физики) взаимодействие электронов с нейтральными атомами нек-рых газов, заключающееся в резком уменьшении сечения упругого рассеяния электронов при небольших (≤ 1 эВ) энергиях столкновения. Р. э. выражается в наличии глубокого минимума в сечении рассеяния, в нек-р. раз меньшего, чем сечение рассеяния при нулевой энергии электронов, так что электроны с энергией ≤ 1 эВ проходят сквозь газ, слабо рассеиваясь. Эффект установлен в 1921 К. Рамзауэром (С. Ramsauer) при изучении рассеяния электронов в аргоне. Р. э. относится как к полному сечению рассеяния, так и к сечению переноса (диффузионному и др.).

Для понимания природы Р. э. сечение рассеяния можно представить в виде суммы парциальных сечений, отвечающих разным моментам столкновения. При нулевой энергии электрова только парциальное сечение для нулевого момента столкновения отлично от нуля. При небольших энергиях электрова, когда др. парциальные сечения еще малы, это сечение обращается в нуль, что приводит к глубокому минимуму в сечении. Р. э. возможен только при рассеянии электрова на атомах с замкнутой электронной оболочкой, когда имеется только одно электронное состояние системы электронов — атом. Др. условием реализации Р. э. является отрицат. динра рассеяния электрова на атоме (см. *Рассеяние микрочастиц*), что обеспечивает обращение в нуль парциального сечения рассеяния с нулевым моментом электрова при небольших его энергиях. Указанные условия выполняются при рассеянии электрова на атомах аргона, криптова, ксенона, где и наблюдается эффект.

Лит.: Друкарев В. Ф., Столкновения электронов с атомами и молекулами, М., 1978. В. М. Смирнов.

РАНГ ГРУППЫ Л и — размерность любой из ее подгрупп Картана, генерированных подгруппой Картана (см. *Ли алгебра*). Р. г. Ли равен рангу эв алгебры Ли. Для матричных групп рангом группы является ранг матриц, образующих группу. Так как всякая группа Ли локально изоморфна нек-рой матричной группе, то ее ранг равен рангу соответствующих матриц.

Лит. см. при ст. *Группы, Ли алгебра*.

РАНГ МАТРИЦЫ — число r , такое, что определитель по крайней мере одной $r \times r$ -матрицы, полученной из данной матрицы удалением нек-рых строк и (или) столбцов, отличен от нуля, а определители всех матриц размерности больше r равны нулю. Р. м. равен наиб. числу линейно независимых строк или столбцов. Квадратная матрица порядка n является невырожденной тогда и только тогда, когда ее ранг $r = n$. Понятие Р. м. позволяет наиб. просто сформулировать условие совместности системы линейных ур-ний: m линейных алгебраич. ур-ний с n неизвестными совместны тогда и только тогда, когда Р. м. коэф.фициентов равен рангу расширенной матрицы. С. И. Алексюк.

РАСКЛАННИВАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ — понятие, относящееся к термодинамике тонких жидких плёнок и характеризующее интенсивность силового взаимодействия между разделяющими (по Дж. В. Гиббсу; J. W. Gibbs) поверхностями и таких плёнок. Подробнее см. *Термодинамика тонких плёнок*. В. Г. Бабак.

РАСПАДНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВОЛН — одна из разновидностей параметр. неустойчивостей, возникающая в нелинейной среде при распространении в ней волн (напр., в плазме). Р. н. в. заключается в том, что в присутствии волны накачки (с частотой ω_0 и волновым вектором k_0), превышающей нек-рый порог по амплитуде, возбуждаются и нарастают по амплитуде одноврем. две волны ω_1, k_1 и ω_2, k_2 , удовлетворяющие условию:

$$\omega_0 = \omega_1 + \omega_2, \\ k_0 = k_1 + k_2.$$

Первым типом Р. и. в., теоретически предсказанным и детально исследованным в плазме в 1962, является неустойчивость ленгмюровской волны. Р. и. в. лежит также в основе вынужденного комбинац. рассеяния (см. подробнее *Вынужденное рассеяние света, Параметрические неустойчивости*).

РАСПЛЫВАНИЕ ПАКЕТА — см. *Волновой пакет*.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — осн. понятие *вероятностной теории* и матем. статистики. Р. полностью характеризует случайную величину. Пусть x — дискретная случайная величина, принимающая (конечное или бесконечное) счётное множество значений $\{x_n\}$. Если вероятность реализации значения x_n равна P_n , т. е. $P(x = x_n) = P_n$, то множество значений вероятностей P_n наз. дискретным Р. вероятности. Вероятности P_n удовлетворяют условиям $P_n > 0$, $\sum P_n = 1$. Предположим, что вероятность рассеяния частицы на мишени равна p . Тогда регистрируемое число рассеянных частиц n — дискретная случайная величина. Р. к-рой является **биномиальным распределением**:

$$P_n = N! p^n (1-p)^{N-n} / n!(N-n)!,$$

где N — число частиц, брошенных на мишень.

Пусть теперь x — непрерывная случайная величина, принимающая любое значение из интервала $[x_{\min}, x_{\max}]$. Если вероятность реализации значения $x < x'$ равна $F(x')$, т. е. $F(x') = P(x < x')$, то $F(x)$ наз. ф-цией распределения, а $f(x)$, определяемая равенством

$$F(x') = \int_{x_{\min}}^{x'} dx f(x),$$

наз. ф-цией плотности вероятности или просто F . Из определения $F(x)$ следует, что

$$F(x_{\min}) = 0, \quad F(x_{\max}) = \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} dx f(x) = 1,$$

$$f(x) dx = F(x+dx) - F(x),$$

т. е. $f(x)$ имеет смысл плотности вероятности на единицу длины. Примером непрерывного Р. является **Максвелла распределение** по скоростям v_x, v_y, v_z частиц макроскопич. системы, находящейся в статистич. равновесии:

$$f(v_x, v_y, v_z) = (m/2\pi kT)^{3/2} \exp \left[-m \left(\frac{v_x^2}{2} + \frac{v_y^2}{2} + \frac{v_z^2}{2} \right) / 2kT \right],$$

где m — масса частицы, T — абс. темп-ра. Это Р. является частным случаем многомерного **Гаусса распределения**.

Наряду с ф-цией плотности вероятности часто используют её фурье-преобразование, наз. **характеристической функцией** Φ случайной величины; для дискретной величины

$$\Phi(t) = M \exp(itx_n) = \sum_n P_n \exp(itx_n),$$

для непрерывной величины

$$\Phi(t) = M \exp(itx) = \int dx f(x) \exp(itx),$$

где M — матем. ожидание. Характеристич. ф-ция полностью определяет Р. случайной величины и часто является более удобным средством её описания. Для дискретной случайной величины x_n с помощью замены $Z = \exp(it)$ часто переходят от характеристич. ф-ции к производящей ф-ции (см. *Производящая функция*):

$$G(Z) = MZ^x = \sum_n P_n Z^{x_n}.$$

Др. способом описания случайной величины является задание её **моментов**

$$\mu_n = Mx^n = \left\{ \sum_i x_i^n P_i, \int dx f(x) x^n \right\}$$

или центральных моментов

$$\mu_n = M(x - Mx)^n.$$

При довольно общих предположениях набор моментов полностью определяет Р. Приведём нек-рые Р., часто используемые в физике и матем. статистике (см. также *Коши распределение, Полиномиальное распределение, Пуассона распределение, Устойчивые распределения*).

Отрицательное биномиальное распределение (распределение Паскаля). Это Р. даёт вероятность затраты r попыток для достижения m успешных попыток. Если p — вероятность успешной попытки, то вероятность r равна

$$P(r) = (r-1)! p^m (1-p)^{r-m} / (m-1)!(r-m)!,$$

ср. значение

$$Mr = m/p,$$

дисперсия

$$Dr = m(1-p)/p^2,$$

производящая ф-ция

$$G(Z) = \left(\frac{pZ}{1-(1-p)Z} \right)^m.$$

χ^2 -распределение. Пусть y_i — независимые случайные величины, подчиняющиеся нормальному Р. с нулевым ср. значением и единичной дисперсией, и пусть $\chi^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2$. Тогда ф-ция плотности вероятности

$$x = \chi^2, \quad f(x) = (x/2)^{n/2-1} \exp(-x/2) / 2\Gamma(n/2),$$

ср. значение

$$Mx = n,$$

дисперсия

$$Dx = 2n,$$

характеристич. ф-ция

$$\Phi(t) = (1-2it)^{-n/2}.$$

Величину n наз. числом степеней свободы. Если x_n и x_m имеют независимые χ^2 -распределения с n и m степенями свободы соответственно, то сумма $x_k = x_n + x_m$ имеет χ^2 -распределение с $k = n + m$ степенями свободы. При $n > 30$ χ^2 -распределение близко к нормальному с теми же ср. значением и дисперсией. Если независимые величины y_i принадлежат нормальному Р. со средними μ_i и единичными дисперсиями, то x имеет центральное χ^2 -распределение с n степенями свободы, к-рое обозначают $\chi^2(n, \Delta)$, где

$\Delta = \sum_{i=1}^n \mu_i^2$ — параметр нецентральности. Характеристич. ф-ция $\chi^2(n, \Delta)$ равна

$$\Phi(t) = \exp \{ \Delta t / (1-2it) \} (1-2it)^{-n/2}.$$

χ^2 -распределение находит широкое применение в проверке *статистических гипотез*.

Распределение Стюдента, t -распределение. Пусть $y_i, i = 1, \dots, n$ — случайные величины, имеющие нормальные Р. со средним μ и дисперсией σ^2 , тогда величина

$$t = n^{1/2}(\bar{y} - \mu) / \sigma,$$

где

$$\bar{y} = \sum_{i=1}^n y_i/n, \quad s^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 / (n-1),$$

подчиняется распределению Стьюдента с ф-цией плотности вероятности

$$f(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{(\pi n)^{1/2} \Gamma(n/2)} (1+t^2/n)^{-(n+1)/2},$$

ср. значением

$$Mt = 0,$$

дисперсией

$$Dt = n/(n-2), \quad n > 2,$$

моментами

$$\mu_{2r} = \frac{n \Gamma(r+1/2) \Gamma(n/2-r)}{\Gamma(1/2) \Gamma(n/2)}, \quad \mu_{2r+1} = 0, \quad 2r < n.$$

При $n \rightarrow \infty$ распределение Стьюдента приближается к нормальному Р. с нулевым средним и единичной дисперсией. С его помощью можно вычислить *доверительные интервалы* для μ и *статистические критерии* проверки гипотез.

Экспоненциальное распределение. Пусть x — положит. случайная величина, λ — положит. параметр, ф-ция плотности вероятности экспоненциального Р.

$$f(x) = \lambda \exp(-\lambda x),$$

ср. значение

$$Mx = \lambda^{-1},$$

дисперсия

$$Dx = \lambda^{-2},$$

характеристич. ф-ция

$$\Phi(t) = (1-it/\lambda)^{-1}.$$

Экспоненциальному Р. подчиняется, напр., время жизни радиоакт. ядер.

Гамма-распределение. Пусть x — положит. случайная величина, a, b — положит. параметры, ф-ция плотности вероятности гамма-распределения равна

$$f(x) = a(a x)^{b-1} \Gamma^{-1}(b) \exp(-a x),$$

ср. значение

$$Mx = b/a,$$

дисперсия

$$Dx = b/a^2,$$

характеристич. ф-ция

$$\Phi(t) = (1-it/a)^{-b}.$$

При $b = 1$ гамма-распределение совпадает с экспоненциальным Р., а при $b = n/2, a = 1/2$ — с χ^2 -распределением с n степенями свободы.

Логарифмически нормальное распределение. Пусть x — положит. случайная величина, логарифм k -рой отвечает нормальному Р. со средним μ и дисперсией σ^2 , тогда ф-ция плотности вероятности

$$f(x) = (\sqrt{2\pi}\sigma x)^{-1} \exp[-(\ln x - \mu)^2 / 2\sigma^2],$$

ср. значение

$$Mx = \exp(\mu + \sigma^2/2),$$

дисперсия

$$Dx = \exp(2\mu + \sigma^2) (\exp \sigma^2 - 1).$$

Лит.: Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. с англ., 3 изд., т. 1—2, М., 1984; Поров Ю. В., Розов Ю. А. Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973; Статистические методы в экспериментальной физике, пер. с англ., М., 1978; Справочник по теории вероятностей и математической статистике, 2 изд., М., 1985; Поров Ю. В., Розов Ю. А., Математическая статистика, М., 1984; В. П. Зигуров. **РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (РОС) — обратная связь** в некоторых типах лазеров, в которых оптич. резонатор образуется благодаря пространственной периодичности неоднородности активной среды (вместо зеркала). Обычно РОС создается с помощью периодич. модуляции показателя преломления (или коэф. усиления) либо периодического пространственного изменения сечения оптич. волновода (в тонкопленочных лазерах). Период пространственной неоднородности d в РОС-лазерах сравним с длиной волны генерируемого излучения λ , и удовлетворяет Брэгга — Вульфа условию:

$$2d \sin \theta = m_0 \lambda_T / n,$$

где m_0 — целое число; n — показатель преломления активной среды; θ — угол скольжения (рис. 1; угол $\theta \neq 90^\circ$ только для тонкопленочных лазеров, в которых реализуется волноводное распространение генерируемого излучения); $I_{\text{н}}, I_{\text{л}}$ — интенсивности волн накачки и излучения соответственно.

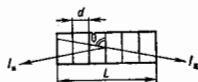


Рис. 1.

Качественно РОС можно интерпретировать как *брегговское отражение* излучения от периодич. структуры в активной среде. Строгая теория РОС рассматривает решение *Максвелла уравнений* для пространственно модулированной среды в виде связанных волн с определенными граничными условиями. Характерной особенностью РОС является высокая спектральная селективность, сравнимая с селективностью отражения от дифракц. решетки размером L (рис. 1). Т. е. ширина полосы, в пределах к-рой осуществляется эфф. РОС, соизмерима с межмодами расстоянием резонатора длиной L , поэтому в РОС-лазерах часто достигается односторонняя генерация.

РОС применяется в *лазерах на красителях* и тонкопленочных *полупроводниковых лазерах*. В лазерах на красителях используется преим. светондущиванная РОС, возникающая в результате периодич. изменения коэф. усиления и показателя преломления при интерференции двух высококогерентных пучков накачки (рис. 2, а и б). Перестройка длины волны в РОС-лазере

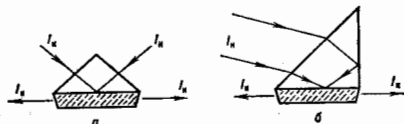


Рис. 2.

на красителях достигается обычно изменением угла между интерферирующими лучами накачки. Используется также изменение темп-ры активной среды. Недостатком лазеров со светондущиванной РОС является

сильная зависимость спектра генерируемого излучения от спектрального состава и расходимости накачки. Так, ширина спектра генерации РОС-лазера $\Delta\lambda_L$ при монохроматич. накачке с расходимостью $\delta\theta$:

$$\Delta\lambda_L = \lambda_L \sqrt{\left(\frac{\lambda_L}{\lambda_{\text{ген}}} \frac{n_{\text{пр}}}{n_c}\right)^2 - 1} \delta\theta,$$

где λ_L , $\lambda_{\text{ген}}$ — длины волны генерации и накачки; $n_{\text{пр}}$, n_c — показатели преломления пазы и активной среды. Несомненные преимущества РОС-лазера состоят в простоте конструкции селективного резонатора и компактности.

В тонкопленочных лазерах (прежде всего полупроводниковых) РОС реализуется обычно с помощью гофрировки ограничивающей боковой поверхности оптич. волновода. Для гофрировки может быть использовано, в частности, травление пленки через защитную маску, созданную из тонкой пленки фоторезиста с помощью засетки интерферирующих световыми лучами.

В тонкопленочных лазерах РОС реализуется дополнит. преимущество, связанное с возможностью дифракц. вывода генерируемого излучения через боковую поверхность волновода (рис. 3). Это уменьшает расходимость выходящего излучения и снижает лучевую нагрузку на торцевые поверхности волновода.

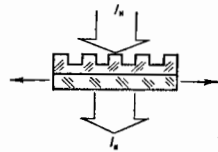


Рис. 3.

Лит.: Лукьяков В. П. и др., Лазеры с распределенной обратной связью, «Квант. электроника», 1975, т. 2, № 11, с. 2373; Рубинов А. Е., Эфендиев Т. Ш., Лазеры на красителях со светонепродуцирующей распределенной обратной связью, там же, 1982, т. 9, № 12, с. 2359. С. М. Колыбаев.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН — процесс передачи в пространстве эл.-магн. колебаний радиодиапазона (см. Радиоволны). В естеств. условиях Р. р. происходит в разл. средах, напр. в атмосфере, космич. плазме, в поверхностном слое Земли.

Общие закономерности распространения радиоволн. Скорость Р. р. в свободном пространстве в вакууме равна скорости света c . Полная энергия, переносимая радиоволной, остаётся постоянной, а плотность потока энергии убывает с увеличением расстояния r от источника обратно пропорционально r^2 . Р. р. в др. средах происходит с фазовой скоростью, отличающейся от c , и в равновесной среде сопровождается поглощением эл.-магн. энергии. Оба эффекта объясняются возбуждением колебаний электронов и ионов среды под действием эл.-нич. поля волны. Если напряжённость поля E гармонич. волны мала по сравнению с напряжённостью поля, действующего на заряды в самой среде (напр., на электрон в атоме), то колебания происходят также по гармонич. закону с частотой ω пришедшей волны. Колебющиеся электроны излучают вторичные радиоволны той же частоты, но с др. амплитудами и фазами. В результате сложения вторичных волн с приходящей формируется результирующая волна с новой амплитудой и фазой. Сдвиг фаз между первичной и переизлученными волнами приводит к изменению фазовой скорости. Потери энергии при взаимодействии волны с атомами являются причиной *поглощения радиоволн*. Амплитуда волны убывает с расстоянием по закону $A = (A_0/r) \exp(-(\omega/c)kr)$, а фаза волны изменяется по закону $\psi = \omega t - (\omega/c)nr$, где k — показатель поглощения, n — *показателя преломления*; n и k зависят от *диэлектрической проницаемости* ϵ среды, её проводимости σ и частоты волн ω :

$$n = \left[\frac{1}{2} \epsilon (\sqrt{1 + \epsilon''/\epsilon'} + 1) \right]^{1/2}, \\ k = \left[\frac{1}{2} \epsilon (\sqrt{1 + \epsilon''/\epsilon'} - 1) \right]^{1/2}, \quad (1)$$

где $\epsilon' = \epsilon''/\epsilon'$ наз. тангенсом угла потерь. Фазовая скорость $v = c/n$, коэф. поглощения $\beta = (k/c)$. Среда ведёт себя как *диэлектрик*, если $\epsilon''/\epsilon' \ll 1$, и как *проводник*, если $\epsilon''/\epsilon' \gg 1$. В первом случае $n \approx \sqrt{\epsilon'}$, $k \approx \frac{1}{2} \sqrt{\epsilon'} \epsilon''/\epsilon'$, во втором — $n \approx k = \sqrt{\epsilon''/2}$, и волна затухает на расстояниях $d = c/\omega k = \frac{c}{2\pi n k}$, d — толщина скин-слоя (см. Скин-эффект). В среде ϵ и σ являются ф-циями частоты (см. Дисперсия волн). Вид частотной зависимости n и k определяется структурой среды. Дисперсия радиоволн особенно существенна в тех случаях, когда частота волны близка к характерным собств. частотам среды (напр., при Р. р. в ионосферной и космич. плазме, см. ниже).

При Р. р. в средах, не содержащих свободных электронов (тропосфера, толща Земли), происходит смещение связанных электронов в атомах и молекулах среды в сторону, противоположную полю волны E , при этом $n > 1$, $v_0 < c$. В плазме поля волны вызывает смещение свободных электронов в направлении E , при этом $n < 1$ и $v_0 > c$, т. е. фазовая скорость монохроматич. волны может быть как меньше, так и больше c . Однако для того чтобы передать при помощи радиоволн к.-л. информацию (энергию), необходимо иметь ограниченный во времени радиосигнал, представляющий собой нек-рый набор гармонич. волн. Спектральный состав сигнала зависит от его длительности и формы. Радиосигнал распространяется с групповой скоростью $v_{гр}$. В любой среде $v_{гр} < c$.

В однородных средах радиоволны распространяются прямолинейно, подобно световым лучам. Процесс Р. р. в этом случае подчиняется законам *геометрической оптики*. Однако реальные среды неоднородны. В них n , а следовательно, и v_0 различны в разных участках среды, что приводит к *рефракции радиоволн*. В случае плавных (в масштабе λ) неоднородностей справедливо приближение геом. оптики. Если показатель преломления зависит только от высоты h , отсюда траектория излучения на поверхности Земли, то путь траектории луча выполняется условие

$$n(h)[1 + h/R_0] \sin \varphi = \sin \varphi_0. \quad (2)$$

Соотношение (2) представляет собой *Снелла закон* преломления для сферической среды. Здесь R_0 — радиус Земли, φ — угол наклона луча к вертикали в произвольной точке траектории. Если вместо действит. показателя преломления n ввести приведенный показатель преломления

$$n_{\text{пр}} = n(h)[1 + h/R_0], \quad (3)$$

то закон преломления (2) получит вид

$$n_{\text{пр}} \sin \varphi = \sin \varphi_0. \quad (4)$$

Соотношение (4) наз. *законом преломления Снелла для плоскостной среды*. Если n убывает при увеличении h , то в результате рефракции луч, по мере распространения, отклоняется от вертикали и на нек-рой высоте h_m становится параллельным горизонтальной плоскости, а затем распространяется вниз (рис. 1, а). Макс. высота h_m , на к-рую луч может углубиться в неоднородную плоскостную среду, зависит от угла падения φ_0 и определяется из условия

$$n(h_m) = \sin \varphi_0. \quad (5)$$

В область $h > h_m$ лучи не проникают, и, согласно приближению геом. оптики, волновое поле в этой области должно быть равно 0. В действительности вблизи плоскости $h = h_m$ волновое поле возрастает, а при $h > h_m$ убывает экспоненциально (рис. 1, б). Нарушение законов геом. оптики при Р. р. связано также с *дифракцией волн*, вследствие к-рой радиоволны могут про-



Рис. 1. а — рефракция радиоволн в плоскослойной среде о град $\pi < \theta$; б — зависимость квадрата амплитуды напряжённости электрического поля радиоволн от высоты h .

никать в область геом. тени. На границе области геом. тени образуется сложное распределение волновых полей. Дифракция радиоволн возникает при наличии на их пути препятствий (непрозрачных или полупрозрачных тел) и особенно существенна в тех случаях, когда размеры препятствий сравнимы с λ .

Если Р. р. происходит вблизи резкой границы (в масштабе λ) между двумя средами с разл. элетрич. свойствами (напр., атмосфера — поверхность Земли или тропосфера — ниж. граница ионосферы для достаточно длинных волн), то при падении радиоволн на резкую границу образуются отражённая и преломлённая (прошедшая) радиоволны. Если отражение происходит от границы проводящей среды (напр., от поверхностного слоя Земли), то глубина проникновения в него определяется толщиной скин-слоя.

В неоднородных средах возможно *волноводное распространение радиоволн*, при к-ром происходит локализация потока энергии между поверхностями, за счёт чего волновые поля между ними убывают с расстоянием медленнее, чем в однородной среде (атм. волновод). В средах с плавными неоднородностями локализация связана с рефракцией, а в случае режек границ — с отражением.

В среде, содержащей случайные локальные неоднородности, вторичные волны излучаются беспорядочно в разл. направлениях. Рассеянные волны частично уносят энергию исходной волны, что приводит к её ослаблению. При рассеянии на неоднородностях размером $l \ll \lambda$ (т. е. в. рассеяние Рэлея; см. *Рассеяние света*) рассеянные волны распространяются почти изотропно. В случае рассеяния на крупномасштабных прозрачных неоднородностях рассеянные волны распространяются в направлениях, близких к исходной волне. При $\lambda \approx l$ возникает сильное резонансное рассеяние.

Влияние поверхности Земли на распространение радиоволн определяется как элетрич. параметрами ϵ и σ грунтов и водных пространств, образующих земную кору, так и структурой поверхности Земли, т. е. её кривизной и неоднородностью. Р. р. — процесс, захватывающий большую область пространства, но набв. существ. роль в Р. р. играет область, ограниченная поверхностью, имеющей форму эллипсоида вращения, в фокусах к-рого А и В на расстояния r расположены передатчик и приёмник (радиотрасса, рис. 2). Большая ось эллипсоида равна $r + \lambda(\pi/4)$, малая ось определяется размерами первой Френелева зоны и $\approx \sqrt{\lambda r/2}$. Ширина трассы уменьшается с убыванием λ . Если высоты z_1 и z_2 , на к-рых расположены антенны передатчика и в приёмника над поверхностью Земли, велики по сравнению с λ , то эллипсоид не касается поверхности Земли и она не влияет на Р. р. (рис. 2, а). При пониженнй обех или одной из конечных точек радиотрассы (или увеличении длины волны) поверхность Земли пересекает эллипсоид. В этом случае на Р. р. оказывают влияние элетрич. параметры области поверхности Земли, ограниченной эллипсом сечения, вытянутым вдоль трассы. При сохранении условий $z_1/\lambda \gg 1$ и $z_2/\lambda \gg 1$ в точке приёма возникает интерференция

между прямой и отражённой волнами (см. *Интерференция волн*). Амплитуда и фаза отражённой волны определяются с учётом Френелева формулы для коэф. отражения. Интерференционные максимумы и минимумы обуславливают лестничную структуру поля, к-рая характерна для декаметровых и более коротких радиоволн. Если $z_1/\lambda < 4$ и $z_2/\lambda < 1$, то радиотрасса выделяет участок поверхности Земли, ограниченный эллипсом с осями $r + \lambda(\pi/4)$ и $\sqrt{\lambda r/2}$. Уменьшение напряжённости поля, а следовательно, и потока энергии, переносимого радиоволной вдоль поверхности Земли

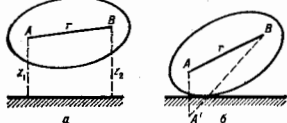


Рис. 2. Эллипсоидальная область пространства, существующая при распространении радиоволн (радиотрасса); А — излучатель, В — приёмник.

(земной волной), обусловлено проводимостью поверхности в этой области. При Р. р. вдоль проводящей поверхности возникает поток энергии, направленный в проводящую среду и быстро затухающий по мере распространения в ней. Глубина проникновения радиоволн в земную кору определяется толщиной скин-слоя $d = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\lambda/\sigma}$, следовательно, увеличивается с увеличением длины волны. Поэтому для подземной и подводной радиосвязи используются длинные и сверхдлинные радиоволны.

Выпуклость земной поверхности ограничивает расстояние, на к-ром из точки приёма В «виден» передатчик А (область «прямой видимости», рис. 3). Однако

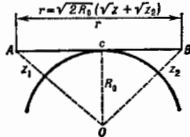


Рис. 3. Дальность «прямой видимости» ограничена выпуклостью земной поверхности; R_0 — радиус Земли, z_1 и z_2 — высоты перемающей А и приёмной В антенн соответственно.

радиоволны, огибая Землю в результате дифракции, могут проникать в область тени на большее расстояние $\sim \sqrt{R_0 \lambda}$ (R_0 — радиус Земли). Практически в эту область за счёт дифракции могут проникать только километровые и более длинные волны (рис. 4).

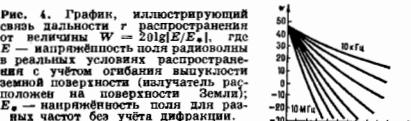


Рис. 4. График, иллюстрирующий связь дальности r распространения от величины $W = 20 \lg(E/E_0)$, где E — напряжённость поля радиоволн в реальных условиях распространения с учётом огибания выпуклости земной поверхности (исключая распространения на поверхности Земли); E_0 — напряжённость поля для равных частот без учёта дифракции.

Фазовая скорость земных волн близка излучателю зависит от элетрич. свойств. Однако на расстоянии в неск. λ от излучателя $z_0 \approx c$. Если радиоволны распространяются над элетрич. неоднородной поверхностью, напр. сначала над сушей, а затем над морем, то при пе-

ресеении береговой линии реако изменяются амплитуда и направление Р. р. (береговая рефракция, рис. 5).

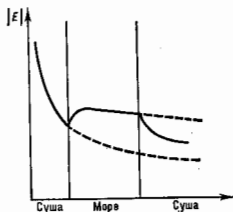


Рис. 5. Изменение напряженности электрического поля волн при пересечении береговой линии.

Влияние рельефа земной поверхности на Р. р. зависит от высоты неровности h , их горизонтальной протяженности l , λ и угла θ падения волны на поверхность. Если неровности достаточно малы и пологи, так что $kh\cos\theta < 1$ (k — волновое число), и выполняется т. и. критерий Рэлея $k^2 l \cos^2\theta < 1$, то они слабо влияют на Р. р. Влияние неровности зависит также от поляризации волн. Напр., для горизонтально поляризованных волн оно меньше, чем для волн, поляризованных вертикально. Когда неровности не малы и не пологи, энергия радиоволн может рассеиваться (радиоволна отражается от них). Высокие горы и холмы с $h > \lambda$ «возмущают» волновое поле, образуя затененные области. Дифракция радиоволн на горных хребтах иногда приводит к усилению волн из-за интерференции прямых и отраженных волн. Вершина горы служит естественным ретранслятором. Это существенно при распространении метровых радиоволн в гористой местности (рис. 6).

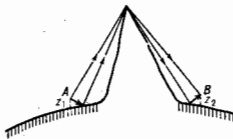


Рис. 6. Траектории радиоволн при дифракции на неровностях.

Распространение радиоволн в тропосфере. Тропосфера — область атмосферы, расположенная между поверхностью Земли и тропопаузой, в к-рой темп-ра воздуха обычно убывает с высотой (в тропопаузе темп-ра с высотой увеличивается). Высота тропопаузы на земном шаре неодинакова, над экватором она больше, чем над полюсами, а в средних широтах, где существует система сильных западных ветров, изменяется скачкообразно. Тропосфера состоит из смеси нейтральных молекул и атомов газов, входящих в состав сухого воздуха, и паров воды. Диэлектрическая проницаемость, а следовательно, и показатель преломления газа, не содержащего свободных электронов и ионов, обусловлены дополнительными полями, создаваемыми смещением электронов в молекулах (поляризация сухого воздуха) и ориентацией полярных молекул (парь воды) под действием электрич. поля волны.

Показатель преломления тропосферы

$$n - 1 = \frac{79}{T} \left(p + \frac{4800}{T} \epsilon \right) 10^{-6}, \quad (6)$$

где p — давление сухого воздуха, ϵ — давление водяного пара в миллибарах, T — темп-ра. Показатель преломления не зависит от частоты и очень мало отличается от единицы. Так, у поверхности Земли с увеличением высоты происходит изменение параметров p , T , ϵ , определяющих значение показателей преломления. При нормальных метеорологич. условиях показатель преломления уменьшается с высотой:

$$\text{grad } n = dn/dh = -4 \cdot 10^{-6} \text{ м}^{-1}.$$

Это приводит к искривлению траектории лучей. Для правильной оценки положения луча относительно поверхности Земли необходимо учитывать сферичность её поверхности, что можно сделать, вводя приведенный показатель преломления (3):

$$\text{grad } n_{\text{пр}} = dn/dh + 1/R_0,$$

отличающийся от $\text{grad } n$ не только по абс. величине, но и по знаку. В условиях нормальной тропосферной рефракции $\text{grad } n_{\text{пр}} > 0$. В этом случае луч, вышедший на приподнятом над землей лучателе под углом $\varphi_0 < \varphi_0^*/2$ к вертикали, при распространении приближается к ней. При $\varphi_0 > \varphi_0^*/2$ распространение лучей происходит в сторону уменьшающихся значений $n_{\text{пр}}$. При этом, в зависимости от значений φ_0 , луч может достигнуть поверхности Земли и отразиться от неё, достигнуть точки поворота, определяемой из условия (5), и при нек-ром значении угла φ_0 точка поворота может лежать на поверхности Земли. В этом случае траектория луча является границей между областью, в к-рую могут попасть лучи, и областью тени. Нормальная тропосферная рефракция способствует увеличению области прямой видимости.

Метеорологич. условия сущест. образом влияют на изменение показателя преломления, т. е. и на рефракцию радиоволн. Обычно в тропосфере давление воздуха и темп-ра с высотой уменьшаются, а давление водяного пара увеличивается. При нек-рых метеорологич. условиях, напр. при движении нагретого над сухой поверхностью воздуха над более холодной поверхностью моря, темп-ра воздуха с высотой увеличивается, а давление водяного пара уменьшается (инверсия темп-ры и влажности). В этом случае показатель преломления изменяется с высотой не монотонно, т. е. $dn_{\text{пр}}/dh$ на нек-рой высоте может изменить знак. Если в интервале высот, определяемом толщиной слоя инверсии, $|\text{grad } n| < 1/R_0$, то $\text{grad } n_{\text{пр}} < 0$. В плоской среде с $\text{grad } n_{\text{пр}} < 0$ лучи отражаются от высоты, определяемой из условия (5). В пространстве, ограниченном снизу поверхностью Земли, а сверху высотой, на к-рой $dn_{\text{пр}}/dh$ изменяет знак, возникают условия для волноводного распространения (рис. 7). В тропосферных волноводах, как правило, могут распространяться волны с $\lambda < 1$ м.

Рис. 7. Траектории УКВ в тропосферном волноводе.

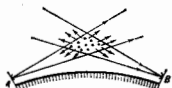


Поглощение радиоволн в тропосфере пренебрежимо мало для всех радиоволн вплоть до сантиметрового диапазона. Поглощение сантиметровых и более коротких волн резко увеличивается, когда частота волны ω совпадает с одной из собств. частот колебаний молекул воздуха (резонансное поглощение). Молекулы получают от приходящей волны энергию, к-рая превращается в тепло и только частично передается вторичным волнам. Известен ряд линий резонансного поглощения в тропосфере: $\lambda = 1,35$ см, 1,5 см, 0,75 см (поглощение в парах воды) и $\lambda = 0,5$ см, 0,25 см (поглощение в кислороде). Между резонансными линиями лежат области более слабого поглощения (окна прозрачности).

Ослабление радиоволн может быть вызвано рассеянием на неоднородностях, возникающих при турбулентном движении воздушных масс (см. Турбулентность). Рассеяние резко увеличивается, когда в воздухе присутствуют капельные неоднородности в виде дождя, снега, тумана. Почти изотропное рассеяние Рэлея на мелкомасштабных неоднородностях делает возможной радиосвязь на расстояниях, значительно превышающих прямую видимость (рис. 8). Т. о.,

тропосфера существенно влияет на распространение УКВ. Для декаметровых и более длинных волн тропосфера практически прозрачна, а на их распространение влияют земная поверхность и более высокие слои атмосферы.

Рис. 8. Рассеяние радиоволн на мелкомасштабных неоднородностях.



Распространение радиоволн в ионосфере. Ионосферу образуют верх. слои земной атмосферы, в к-рой газы частично (до 1%) ионизированы под влиянием УФ, рентг. и корпускулярного солнечного излучения. Ионосфера электрически нейтральна, она содержит равное кол-во положит. и отрицат. частиц, т. е. является плазмой. Достаточно большая ионизация, оказывающая влияние на Р. р., начинается на высоте 60 км (слой D), увеличивается до высоты 300—400 км, образуя слои E, F₁, F₂, и затем медленно убывает. В гл. максимум концентрации электронов N достигает 10⁸ см⁻³. Зависимость N от высоты меняется со временем суток, года, с солнечной активностью, а также с широтой и долготой. Ионизиров. слой между 200 и 400 км состоит в осн. из равного кол-ва ионов O⁺ и электронов. Эти частицы погружены в нейтральный газ с концентрацией 10¹⁸ см⁻³, состоящий в осн. из частиц O₂, O, N₂ и He.

В многокомпонентной плазме, содержащей электроны, ионы и нейтральные молекулы и ионизированной магн. полем Земли (см. *Земной магнетизм*), могут возникать разл. виды собств. колебаний, имеющих разные частоты. Напр., плазменные (ленгмювские) частоты электронов $\omega_0 = \sqrt{4\pi N e^2/m}$ и ионов $\Omega_0 = \sqrt{4\pi N_i^2/M}$, гиромат. частоты электронов $\omega_H = eH_0/mc$ и ионов $\Omega_H = eH_0/Mc$, где m , M — массы электрона и иона, e — их заряд, N — концентрация, H_0 — напряжённость магн. поля Земли. Т. к. $M \gg m$, то $\omega_0 \gg \Omega_0$, $\omega_H \gg \Omega_H$. Напр., для электронов $\omega_H/2\pi = 4.4$ МГц, а для ионов атомарного кислорода $\Omega_H/2\pi = 54$ Гц.

В зависимости от частоты ω радиоволн осн. роль в Р. р. играют те или др. виды собств. колебаний, поэтому свойства ионосферы различны для разных участков радиодиапазона. При высоких ω ионы не успевают следовать за изменениями поля и в Р. р. принимают участие только электроны. Вынужденные колебания свободных электронов ионосферы происходят в противофазе с действующей силой и вызывают поляризацию плазмы в сторону противоположную электрич. полю волны E. Поэтому диэлектрич. проницаемость ионосферы $\epsilon < 1$. Она уменьшается с уменьшением частоты: $\epsilon = 1 - \omega_0^2/\omega^2$. Учёт соударений электронов с атомами и ионами даёт более точные ф-лы для ϵ и σ ионосферы:

$$\epsilon = 1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2 + \nu^2}; \quad \sigma = \frac{\omega_0^2 \nu}{4\pi(\omega^2 + \nu^2)}.$$

Здесь ν — эфф. частота соударений. Для декаметровых и более коротких волн в большей части ионосферы $\omega^2 \gg \nu^2$ и показатели преломления n и поглощения κ приближённо равны:

$$n \approx \sqrt{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}}, \quad \kappa \approx 2\pi\sigma/\omega\sqrt{\epsilon}.$$

Поскольку $n < 1$, фазовая скорость Р. р. $v_{\phi} = c/n > c$, групповая скорость $v_{гр} = c/n < c$.

Поглощение в ионосфере пропорц. ν , т. к. чем больше число столкновений, тем большая часть энергии, получаемой электроном из волн, переходит в тепло. Поэтому поглощение больше в ниж. областях ионосферы (слой D), где ν больше, т. к. выше плотность газа. С увеличе-

нием частоты поглощение уменьшается. Короткие волны испытывают слабое поглощение и распространяются на большие расстояния.

Рефракция радиоволн в ионосфере. В ионосфере распространяются только радиоволны с частотой $\omega > \omega_0$. При $\omega < \omega_0$ показатель преломления становится чисто мнимым и эл.-магн. поле экспоненциально убывает в глубь плазмы. Радиоволна с частотой ω , падающая на ионосферу вертикально, отражается от уровня, на к-ром $\omega = \omega_0$ и $n = 0$. В ниж. части ионосферы электронная концентрация и ω_0 увеличиваются с высотой, поэтому с увеличением ω посланная с Земли волна всё глубже проникает в ионосферу. Макс. частота радиоволны, к-рая отражается от слоя ионосферы при вертикальном падении, наз. критич. частотой слоя:

$$\omega_{кр} = \omega_{кр \text{ макс}} = \sqrt{4\pi e^2 N_{\text{макс}}/m}.$$

Критич. частота слоя F₂ (гл. максимума) изменяется в течение суток и года в широких пределах (от 3—5 до 10 МГц). Для волн с $\omega > \omega_{кр}(F_2)$ показатель преломления не обращается в нуль и падающая вертикально волна проходит через ионосферу, не отражаясь.

При наклонном падении волны на ионосферу происходит рефракция, как в тропосфере. В ниж. части ионосферы $\text{grad } n \approx -(10^{-4} - 10^{-5}) \text{ м}^{-1}$, т. е. $|\text{grad } n| \gg 1/R_0$, поэтому $\text{grad } n_{\text{пр}} \approx \text{grad } n < 0$ и траектория луча отклоняется по направлению к Земле (рис. 9). Радиоволна, падающая на ионосферу под углом φ_0 , поворачивается



Рис. 9. Схематическое изображение радиоволны определенной частоты при различных углах падения на ионосферу.

к Земле на высоте h , для к-рой выполнено условие (5). Макс. частота волны, отражающейся от ионосферы при падении под углом (т. е. для данной дальности трассы), равна $\omega_{мпч} = \omega_{кр} \text{sec } \varphi_0 > \omega_{кр}$ и наз. максимальной применимой частотой (МПЧ). Волны с $\omega < \omega_{мпч}$, отражаясь от ионосферы, возвращаются на Землю, что используется для дальней радиосвязи. Вследствие сферичности Земли величина угла φ_0 ограничена и дальность связи при однократном отражении от ионосферы ≤ 3500 —

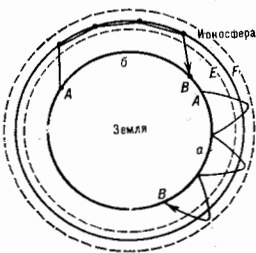


Рис. 10. Распространение коротких волн между Землей и ионосферой: а — многосвязная траектория; б — связная траектория.

4000 км. Связь на большие расстояния осуществляется за счёт неск. последоват. отражений от ионосферы и Земли (скачков, рис. 10, а). Возможны и более сложные

волноводные траектории, возникающие за счёт горизонтального градиента N или рассеяния на неоднородностях ионосферы при P . p с частотой $\omega > \omega_{МП}$. В результате рассеяния угол падения луча на слой F_2 оказывается больше, чем при обычном распространении. Луч испытывает ряд последоват. отражений от слоя F_2 , пока не попадёт в область с таким градиентом N , к-рый вызовет отражение части энергии назад к Земле (рис. 10, 6).

Влияние магнитного поля Земли H_0 в магн. поле H_1 на электрон, движущийся со скоростью v , действует Лоренца сила $F = (-e/c)[vH_1]$, под влиянием к-рой он вращается по окружности в плоскости, перпендикулярной H_0 , с гироманг. частотой ω_H . Траектория каждой заряд. частицы — винтовая линия с осью вдоль H_0 . Действие силы Лоренца приводит к изменению характера вынужденных колебаний электронов под действием элетрич. поля волны, а следовательно, к изменению элетрич. свойств среды. В результате ионосфера становится анизотропной гиротропной средой, элетрич. свойства к-рой зависят от направления P . p и описываются не скалярной величиной ϵ , а тензором диэлектрич. проницаемости ϵ_{ij} . Падающая на такую среду волна испытывает *двойное лучепреломление*, т. е. расщепляется на две волны, отличающиеся скоростью и направлением распространения, поглощением и поляризацией. Если направление P . p $\perp H_0$, то падающую волну можно представить себе в виде суммы двух линейно поляризованных волн с $E \perp H_0$ и $E \parallel H_0$. Для первой, «обыкновенной», волны (e) характер вынужденного движения электронов под действием поля волны E изменяется (появляется) компонента ускорения, перпендикулярная E и поэтому меняется n . Для второй, «обыкновенной», волны (o) вынужденное движение остаётся таким же, как и без поля H_0 (при $v \parallel H_0$ сила Лоренца равна 0). Для этих двух волн (без учёта соударений) квадраты показателей преломления равны

$$\frac{n_e^2}{c} = 1 - \frac{\omega_p^2(\omega^2 - \omega_e^2)}{\omega^2(\omega^2 - \omega_e^2 - \omega_H^2)}; \quad \frac{n_o^2}{c} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad (7)$$

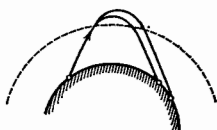
При P . p вдоль H_0

$$\frac{n_e^2}{c} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - \omega_H)}; \quad \frac{n_o^2}{c} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \omega_H)} \quad (8)$$

В последнем случае обе волны имеют круговую поляризацию, причём у «необыкновенной» волны вектор E вращается в сторону вращения электрона, а у «обыкновенной» — в противоположную сторону. При произвольном направлении P . p (относительно H_0) поляризация нормальных волн эллиптическая.

По мере P . p в ионосфере увеличивается сдвиг фаз между волнами и изменяется поляризация суммарной волны. Напр., при P . p вдоль H_0 это приводит к повороту плоскости поляризации (*Фарадея эффект*), а при P . p перпендикулярно H_0 — к периодич. чередованию линейной и круговой поляризации (см. *Коттона — Мутона эффект*). Т. к. показатели преломления волн различны, отражение их происходит на разной высоте (рис. 11). Направление волнового вектора k при P . p в ионосфере может отличаться от $v_{гр}$.

Рис. 11. Расщепление радиоволн в результате двойного лучепреломления в ионосфере.



Низкочастотные волны в ионосфере. Оси. часть энергии НЧ-радиоволн практически не проникает в ионосферу. Волны отражаются от её ниж. границы (днём —

вследствие сильной рефракции в D -слое, ночью — от E -слоя, как от границы двух сред с равными элетрич. свойствами). Распространение этих волн хорошо описывается моделью, согласно к-рой однородные и изотропные Земля и ионосфера образуют призматич. волновод с режисми сферич. стенками, в к-ром и происходит P . p . Такая модель объясняет наблюдаемое убывание поля с расстоянием и возрастание амплитуды поля с высотой. Последнее связано со скоплением волн вдоль вогнутой поверхности волновода, приводящими к своеобразной «фокусировке» поля. Это явление аналогично открытому Рэлеем в акустике эффекту «шепчущей галереи». Амплитуда радиоволн значительно возрастает в антиподной по отношению к источнику точке Земли. Это объясняется сложением радиоволн, огибающих Землю по всем направлениям и сходящихся на противоположной стороне.

Влияние магн. поля Земли обуславливает ряд особенностей распространения НЧ-волн в ионосфере: сверхдлинные волны могут выходить из призматич. волновода за пределы ионосферы, распространяясь вдоль силовых линий геомагн. поля между сопряжёнными точками A и B Земли (рис. 12). Из ф-лы (8) видно, что при $\omega \ll \omega_H$ в случае продольного распространения $n_e^2 \approx \omega_p^2/\omega^2$ нигде не обращается в 0, т. е. волна проходит через ионосферу без отражения.

В ночной атмосфере приближение геом. оптики нарушается и частичное прохождение есть при любом угле падения. Разряды молний в атмосфере — естеств. источник НЧ-волн. В диапазоне 1—40 кГц они приводят к образованию т. н. свистящих атмосферных, к-рые распространяются указанным образом и создают на выходе приёмника сигнал с характерным свистом.

При P . p инфразвуковых частот $\omega \ll \omega_H$ важную роль играют колебания ионов, ионосфера ведёт себя как проводящая нейтральная жидкость, движение к-рой описывается ур-ниями *магнитной гидродинамики*. В ионосфере возможно распространение неск. типов магнитогидродинамич. волн, в частности *альевенских волн*, распространяющихся вдоль геомагн. поля с характерной скоростью $v_A = H_0/\sqrt{4\pi\rho}$ (где ρ — плотность газа), и магнитозвуковых волн, к-рые распространяются изотропно (подобно звуку).

Нелинейные эффекты при распространении радиоволн в ионосфере проявляются уже для радиоволн сравнительно небольшой интенсивности и связаны с нарушением линейной зависимости поляризации среды от элетрич. поля волны (см. *Нелинейная оптика*). «Нагревая» нелинейность играет осн. роль, когда характерные размеры возмущённой элетрич. полем области плазмы во много раз больше длины свободного пробега электронов. Т. к. длина свободного пробега электронов в плазме значительна, электрон успевает получить от поля заметную энергию за время одного пробега. Передача энергии при столкновениях от электронов к ионам, атомам и молекулам затруднена на-за большого различия в их массах. В результате электроны плазмы сильно «нагреваются» уже в сравнительно слабом элетрич. поле, что изменяет эфф. частоту соударений. Поэтому ϵ и σ плазмы становятся зависящими от поля E волны и P . p приобретает нелинейный характер. «Возмущение» диэлектрич. проницаемости $\Delta\epsilon_N \sim \sim (E/E_p)^2$, где $E_p = \sqrt{3(T\pi b^2/e^2)(\omega^2 + \nu^2)}$ — характерное «плазменное» поле, T — темп-ра плазмы, b — ср. доля энергии, теряемая электроном при одном соударении с тяжёлой частицей, ν — частота соударений.

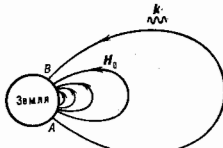


Рис. 12.

Т. о., нелинейные эффекты становятся заметными, когда поле волны E сравнимо с E_p , k -рое в зависимости от частоты волны и области ионосферы составляет $\sim 10^4 - 10^7$ В/см.

Нелинейные эффекты могут проявляться как самовоздействие волны и как взаимодействие волн между собой. Самовоздействие мощной волны приводит к изменению её поглощения и глубины модуляции. Поглощение мощной радиоволны нелинейно зависит от её амплитуды. Частота соударений ν с увеличением темп-ры электронов может как расти (в ниж. слоях, где ос. роль играют соударения с нейтральными частицами), так и убывать (при соударениях с ионами). В первом случае поглощение резко возрастает с увеличением мощности волны («насыщение» поля в плазме). Во втором случае поглощение падает (т. е. просветление плазмы для мощной радиоволны). Из-за нелинейного изменения поглощения амплитуда волны нелинейно зависит от амплитуды падающего поля, поэтому её модуляция искажается (автомодуляция и демодуляция волн). Изменение n в поле мощной волны приводит к искривлению траектории луча. При распространении укорянных пучков радиоволн это может привести к самофокусировке пучка аналогично самофокусировке света и к образованию волноводного канала в плазме.

Взаимодействие волн в условиях нелинейности приводит к нарушению суперпозиции принципа. В частности, если мощная волна с частотой ω_1 модулирована по амплитуде, то благодаря изменению поглощения эта модуляция может передаваться др. волне с частотой ω_2 , входящей в той же области ионосферы (рис. 13) Это явление, называемое кросс-модуляцией или *Люксембург-Горьковским эффектом*, имеет практич. значение при радиовещании в диапазоне ср. волн.

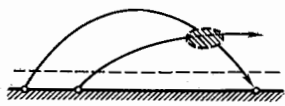


Рис. 13. Ионосферная кросс-модуляция происходит в области пресечения лучей.

Нагрев ионосферы в поле мощной волны в КВ-диапазоне может вызвать тепловую параметрич. неустойчивость в ионосфере, k -рая приводит к аномально большому поглощению радионизлучения и рассеянию плазмы (см. *Параметрический резонанс*). В области резонанса $\omega = \sqrt{\omega_p^2 + \omega_H^2}$ образуются сильно вытянутые вдоль H_0 неоднородности ионосферы (с продольным масштабом 4 км, поперечным $\sim 0.5 \div 100$ м), k -рые перспективны для дальней связи в диапазоне УКВ. В поле очень мощных радиоволн электроны столь сильно разогреваются, что возникают электр. пробой газа.

Если размеры возмущённой полем волны области плазмы много меньше длины свободного пробега электронов, n k -ра в горячей n k -ельнейность становится слабой. Это имеет место при коротких импульсах и узких пучках радиоволн. В этом случае осн. роль играют т. н. ст р и к ц и о н а я нелинейность, связанная с тем, что неоднородное перем. электр. поле волны оказывает давление на электроны, вызывающее сжатие плазмы. Концентрация электронов N , а следовательно, ϵ и σ становятся зависящими от амплитуды поля. Стрикционная нелинейность приводит к изменению диэлектрич. проницаемости $\Delta \epsilon_c \approx e^2 E^2 / 8 T m \omega^2$, меньшей нагреваемой именованной $\Delta \epsilon_b$ на нек. порядков (при той же мощности волны). Стрикционная нелинейность играет важную роль в параметрич. неустойчивости ионосферы.

260 Распространение радиоволн в космических условиях. За исключением планет и их ближайших окрестностей,

б. ч. вещества во Вселенной ионизована. Параметры космич. плазмы меняются в широких пределах. Напр., концентрация электронов и ионов близка орбиты Земли $\sim 1-10$ см $^{-3}$, в ионосфере Юпитера $\sim 10^8$ см $^{-3}$, в солнечной короне $\sim 10^8$ см $^{-3}$, в недрах звёзд $\sim 10^{27}$ см $^{-3}$. Из космич. пространства к Земле приходит широкий спектр эл.-магн. волн, k -рые на пути из космоса должны пройти через ионосферу и тропосферу. Через атмосферу Земли без заметного затухания распространяются волны двух осн. частотных диапазонов: «радиокосмос» соответствует диапазону от ионосферных критич. частот ω_{cr} до частот сильного поглощения аэрозольными и газами атмосферы (10 МГц — 20 ГГц), «открыт. окно» охватывает диапазон видимого в ИК-излучения (1—10 10 ГГц). Атмосфера также частично прозрачна в диапазоне НЧ (<300 кГц), где распространяются свистящие атмосферки и магнитогидродинамич. волны.

В космос, условиях источник радиоволн и их приёмник часто быстро движутся один относительно другого. В результате *Доплера эффекта* это приводит к изменению ω на $\Delta \omega = kv$, где v — относит. скорость. Повы-

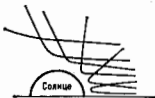


Рис. 14. Траектории радиолучей с $\lambda = 5$ м в солнечной короне.

жение частоты при удалении корреспондентов (*красное смещение*) свойственно излучению удаляющихся от нас далёких галактик. Радиоволны в космич. плазме подвержены рефракции, связанной с неоднородностью среды (рис. 14). Напр., вследствие рефракции в атмосфере Земли источник радиоволн виден выше над горизонтом, чем в действительности. Для определения расстояния до пульсаров и при интерпретации результатов радиолокации Солнца и планет необходимо учитывать, что в космич. плазме $v_{ф} \neq c$.

Возможности радиосвязи с объектами, находящимися в космич. пространстве или на др. планетах, разнообразны и связаны с наличием и строением их атмосферы. Если космич. плазма находится в магн. поле (магнитосфера Юпитера, области солнечных пятен, магнитосферы пульсаров), то она является гигрошной средой, подобно земной ионосфере. Для всех планет с атмосферами общая трудность радиосвязи состоит в том, что при входе космич. аппарата в плотные слои атмосферы вокруг него создаётся плотная плазменная оболочка, затрудняющая прохождение радиоволн. На планетах титя Меркурия и Луны, практически не имеющих атмосферы и ионосферы, на Р. k -ре оказывает влияние только поверхность планеты. Из-за отсутствия отражения от ионосферы дальность связи вдоль поверхности такой планеты невелика (рис. 15) и может быть увеличена только при помощи ретрансляции через спутник.

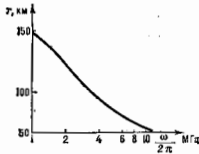


Рис. 15. Зависимость дальности r радиосвязи от поверхности Луны от частоты $\omega/\Delta \lambda$.

Распространение радиоволн разных диапазонов. Радиоволны очень низких (3—30 кГц) и низких (30—300 кГц) частот отгибают земную поверхность вследствие волноводного распространения и дифракции, сравнительно слабо проникают в ионосферу и мало поглощаются

ею. Отличаются высокой фазовой стабильностью и способностью равномерно покрывать большие площади, включая полярные районы. Это обуславливает возможность их использования для устойчивой дальней и сверхдальней радиосвязи и радионавигации, несмотря на высокий уровень атм. помех. Полоса частот от 150 до 300 кГц используется для радиовещания. Большое число геофиз. исследований выполняется путём наблюдений за сигналами естествен. происхождения, к-рые генерируются, напр., молниевыми разрядами и частями радиац. поясов Земли. Трудности применения этого частотного диапазона обусловлены громоздкостью антенных систем с высоким уровнем атм. помех, с относит. ограниченностью скорости передачи информации.

Средние волны (300—3000 кГц) днём распространяются вдоль поверхности Земли (земная, или прямая, волна). Отражённая от ионосферы волна практически отсутствует, т. к. волны сильно поглощаются в D-слое ионосферы. Только из-за отсутствия солнечного излучения D-слой исчезает, появляется ионосферная волна, отражённая от E-слоя, и дальность приёма возрастает. Сложение прямой и отражённой волн влечёт за собой сильную изменчивость поля, поэтому ионосферная волна — источник помех для мр. служб, использующих распространение земной волны. Ср. волны применяются для радиовещания, радиотелеграфной и радиотелефонной связи, радионавигации.

Короткие волны (3—30 МГц) слабо поглощаются D- и E-слоями и отражаются от F-слоя, когда их частота $\nu < \omega_{\text{МПЧ}}$. В результате их отражения от ионосферы возможна связь как на малых, так и на больших расстояниях при значительно меньшем уровне мощности передатчика и гораздо более простых антеннах, чем в более низкочастотных диапазонах. Этот диапазон применяется для радиотелеграфной и радиотелеграфной связи, радиовещания, а также для радиодальностной связи. Особенность радиосвязи в этом диапазоне — наличие замираний (феддинга) сигнала из-за изменений условий отражения от ионосферы и интерференц. эффектов. КВ-линии связи подвержены влиянию атм. помех. Ионосферные бури вызывают прерывание связи.

Для очень высоких частот и УКВ (30—1000 МГц) преобладает P. p. внутри тропосферы и проникновение сквозь ионосферу. Роль земной волны падает. Поля в НЧ-части этого диапазона всё ещё могут определяться отражениями от ионосферы, и до частоты 60 МГц ионосферное рассеяние продолжает играть значит. роль. Все виды P. p., за исключением тропосферного рассеяния, позволяют передавать сигналы с прямой полосой частот в неск. МГц. В этой части спектра возможно очень высокое качество звукового радиовещания при дальности 50—100 км. Радиовещание с частотной модуляцией работает на частотах вблизи 100 МГц.

В этом же диапазоне частот ведётся телевизионное вещание. Для радиостроения выделено неск. узких спектральных полос, к-рые используют также для космич. связи, радиолокации, метеорологии, кроме того, для любительской связи.

Волны УВЧ и СВЧ (1000—10 000 МГц) распространяются в осв. в пределах прямой видимости и характеризуются низким уровнем шумов. В этом диапазоне при P. p. играют роль известные области макс. поглощения и частоты излучения хим. элементов (напр., линии водорода вблизи 1420 МГц). В этом диапазоне размещены многоканальные системы широкополосной связи для передачи телефонных и телевизионных сигналов. Высокая направленность антенн позволяет использовать внятный уровень мощности в радиорелейных системах, а тропосферное рассеяние обеспечивает дальность радиосвязи ~ 800 км. Этот диапазон применяют в радионавигации, радиолокации, службах. Для радиостроения наблюдений выделены полосы частот за атмосферным водо-

дом, радикалом ОН и континуальным излучением. В космич. радиосвязи полоса частот ~ 1000—10 000 МГц — наиб. важная часть радиодиапазона.

Волны СВЧ (>10 ГГц) распространяются только в пределах прямой видимости. Потери в этом диапазоне неск. выше, чем на более низких частотах, причём на их величину сильно влияет кол-во осадков. Рост потерь на этих частотах частично компенсируется возрастанием эффективности антенных систем. СВЧ служат в радиолокации, радионавигации и метеорологии. На линиях связи между поверхностью Земли и космосом могут использоваться частоты < 20 ГГц. Для связи в космосе могут применяться значительно более высокие частоты. При этом отсутствуют взаимные помехи между космич. и некосмич. службами. Диапазон СВЧ важен также для радиостроения.

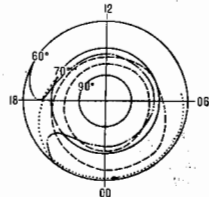
Лит.: Долуханов М. П., Распространение радиоволн, 4 изд., М., 1972; Вреховских Л. М., Волны в слоистых средах, 2 изд., М., 1973; Ги и з б у р г В. Д., Распространение электромагнитных волн в плазме, 2 изд., М., 1967; Гаттарский В. И., Распространение волн в турбулентной атмосфере, М., 1967; Фок В. А., Проблема дифракции и распространения электромагнитных волн, М., 1970; Гуревич А. В., Шварцбург А. В., Исчисленная теория распространения радиоволн в ионосфере, М., 1973; Железняков В. В., Электромагнитные волны в космической плазме, М., 1977.

П. А. Веспалов, М. В. Виноградова.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН в высоких широтах — ионосферная радиосвязь в диапазоне радиоволн 3—30 МГц, к-рую отличают отсутствие стабильности и низкое качество, что обусловлено специфической средой распространения — сложной неоднородной структурой полярной ионосферы, формируемой процессами взаимодействия ионосферы, магнитосферы Земли и возмущений плазмы в межпланетном пространстве (см. также Солнечный ветер). На низких широтах силовые линии магн. поля проходят горизонтально над магн. экватором, остаются глубоко внутри магнитосферы. В высоких широтах силовые линии близки к вертикальным и уходят далеко от Земли в область внеш. магнитосферы или межпланетного пространства. Т. к. заряд. частицы могут легко двигаться вдоль силовых линий, а поперёк с трудом, то ионосфера низких и средних широт защищена от возмущений в солнечном ветре, в то время как полярная ионосфера реагирует на них. Т. о., в полярной ионосфере присутствуют два агента ионизации: первый, как и на ср. широтах, — УФ-излучение Солнца и второй — корпускулярные потоки. При этом второй агент часто оказывается преобладающим, напр. в условиях затёвнённой ионосферы и в период геомагн. возмущений (суббури).

Структурные зоны высокоширотной атмосферы, отличающиеся особенностями P. p.:

1. Авроральный овал (АО) — область повышенной активности полярных сияний, аномально повышенной ионизации как в слоях E и F, так и на больших высотах (вплоть до 1000 км); расположен асимметрично относительно геомагн. полюса и фиксирован относи-

Среднее положение аврорального овала (штриховая линия), минимума электронной концентрации верхней ионосферной призмы (точки) и волны аврорального поглощения (штрих-пунктир).



тельно Солнца. В ночные часы он попадает на геомагн. широты 60—70°, в дневные — на широты 70—80° (рис.).

2. Главный ионосферный провал (ГИП) — область пониженной ионизации, граничащая с полярной стороны с АО. В ночные часы ГИП наблюда-

ется на геомагн. широтах $50-60^\circ$, в дневные часы примерно на $72-75^\circ$; наб. выражен в ночные и утренние часы и практически отсутствует в полуденные часы.

3. В м-к о с о ш и р о т а я п о л о с т ь — область пониженной ионизации к полюсу от АО, как в слое F, так и ниже. Направленные вверх потоки лёгких ионов (O^+ , H^+), т. е. полярный ветер, приводит к истощению ионосферы в этой области.

4. З о н а а в р о р а л ь н о г о п о г л о щ е н и я — область повышенной ионизации в слое D и ниж. части слоя E, к-рая образуется вследствие вторжения в ионосферу потоков энергичных электронов (с энергией > 40 кэВ). Это кольцевая область в интервале геомагн. широт $60-74^\circ$, раюмикающая на вечерней стороне Земли ($18-20$ ч местного времени).

Аномально высокая ионизация в слое F в зоне АО или, наоборот, пониженная ионизация в области ГИП приводит к вариации верх. предела диапазона частот — максимальной наблюдаемой частоты. С др. стороны, аномальное поглощение в ниж. ионосфере ведёт к сужению диапазона частот за счёт роста его ниж. предела — наименьшей наблюдаемой частоты.

Аномально повышенное поглощение ВЧ-радиоволн в полярной ионосфере является одной из гл. причин нарушения связи и возникает в результате увеличения концентрации заряд. частиц в слое D. Различают 4 типа аномального поглощения, каждый из к-рых соответствует определ. фазе в ходе развития ионосферного возмущения, следующего за вспышкой на Солнце: в е а з а п о с о г л о щ е н и е (ВП), наблюдаемое на всей освещённой полусфере Земли, обусловленное прямой эмиссией излучения во время солнечных вспышек; п о г л о щ е н и е п о л я р н о й ш а п к и (ППШ), к-рое наблюдается в приполюсной области на широтах, превышающих $\Phi \approx 60^\circ$; п о г л о щ е н и е с в я з а н н ы м н а ч а л о м (ПВН), возникающее в период внезапного начала магн. бури в зоне полярных сияний. Обусловлено всплсками тормозного рентг. излучения электронов, высмпающихся в ионосферу АО в результате резкого снятия земной магнитосферы под воздействием ударного фронта потока солнечной плазмы; по интенсивности и продолжительности соответствует эффекту ВП; а в р о р а л ь н о е п о г л о щ е н и е (АП).

Поглощения типа ВП в ПВН появляются сравнительно редко, имеют малую продолжительность (неск. десятков минут) и поэтому не играют существ. роли в радиосвязи.

ППШ появляется после хромосферных вспышек на Солнце, сопровождаемых потоками солнечных космических лучей, в осн. протонев. На нач. фазе явления иногда регистрируются потоки солнечных электронов. Ослабление радиосигналов может достигать 100 дБ. Интенсивное поглощение ВЧ-радиоволн начинается спустя неск. часов после вспышки на Солнце — выачеле вблиз геомагн. полюса, затем постепенно охватывает всю полярную область на широтах $\Phi \geq 60^\circ$. В зависимости от степени освещённости Солнцем полярных областей Земли поглощение радиоволн в ионосфере затухает в течение 2—3 сут до исходного фонового значения. Продолжительность ППШ может достигать 10 сут и более. Явление ППШ максимально днём и минимально ночью, развивая при этом составляют 4—6 раз. В сезонном распределении явлений ППШ нет чёткой закономерности, однако можно отметить нам. вероятность появления ППШ в декабре. Наб. число случаев ППШ наблюдается в годы высокой солнечной активности (порядка 15—20 интенсивных событий), в годы низкой солнечной активности ППШ практически не наблюдается.

АП — наиболее часто встречающийся тип поглощения в высоких широтах, доставляющий наиб. трудности в поддержании устойчивой связи. Вероятность появления АП может достигать 40%. Появление АП в ночное время тесно связано с полярными сияниями и ло-

кальными магн. возмущениями. Продолжительность индивидуальных случаев АП обычно не превышает 2 ч, однако чаще всего АП наблюдается в виде серии событий, накладывающихся одно на другое. Источником увеличения ионизации в D-области, ответственной за явление АП, являются потоки энергичных электронов с энергией $E \geq 40$ кэВ из магнитосферы, вторгающиеся в полярную ионосферу на уровне области D и ниж. части области E (высоты $60-80$ км). Максимум АП как по частоте появления, так и величине происходит на широтах $\Phi \approx 64-67^\circ$. Характерной особенностью АП является существование чёткой суточной вариации с двумя максимумами (дневным и ночным) и вечерним минимумом ($18-20$ ч местного времени). В сезонном ходе выделяются два равноденственных максимума, весной и осенью, из к-рых наибольший — весенний. Особенности пространственно-временного распределения АП определяются уровнем магн. активности. С ростом магн. активности центр зоны АП смещается к югу на $\Phi \approx 63-65^\circ$, зона расширяется почти вдвое и дневной максимум с $10-12$ ч местного времени смещается на более ранние часы ($6-8$ ч).

По характеру влияния АП на условия распространения ВЧ-радиоволн все трассы можно разбить на три группы.

1. Трассы, целиком проходящие внутри полярной шапки и не пересекающие зоны АП. На таких трассах АП практически отсутствует и надёжность связи может быть близка 100%, если исключить события ППШ.

2. Трассы, у к-рых хотя бы один из конечных пунктов расположен в зоне АП. На таких трассах наблюдаются набв. нарушения прохождения радиоволн. Хорошие условия связи, когда прохождение достигает 80—90%, возможны лишь сравнительно ограниченное время. Ослабление ВЧ-сигналов может достигать 30—60 дБ в зависимости от частоты излучения.

3. Трассы, пересекающие зону АП, когда передающий и приёмные пункты расположены относительно далеко от зоны. В этом случае условия радиосвязи более благоприятные, чем во втором случае: на оптм. частотах прохождение радиоволн составляет 90%. Большую роль при этом играют спорадич. слои E, наблюдающиеся в области АО на высотах E-области ~ 110 км и связанные с высмпаением электронов с энергией $1-10$ кэВ. Их можно разбить на две группы: E_1 с групповым запаздыванием в плоские E. Вероятность появления E_1 в зоне АО достигает 80—90%, а концентрация электронов в максимуме слоя сравнима с электронной концентрацией в слое F. Такая ситуация способствует образованию волноводных каналов между слоями E_1 и F. Попадая в такой канал, радиоволна как бы пересекает зону АП, испытывая существенно меньшее поглощение (см. *Волноводное распространение радиоволн*).

На P. большое влияние оказывают область АО, как набв. нерегулярная с широким спектром мелко-масштабных неоднородностей от сотен м до десятков км, к-рые могут быть результатом как прямого высмпаения энергичных частиц, так и следствием плазменных неустойчивостей, связанных с электрич. полями магнитосферного происхождения, а также область ГИП с большими горизонтальными градиентами электронной концентрации. Эффект горизонтальных градиентов ГИП и в ряде случаев и рассеяние на неоднородностях АО состоит в появлении нестандартного ВЧ-распространения с отклонением траектории радиоволн от плоскости дуги большого круга. Эти т. н. азимутальные отклонения траекторий достигает $10-30^\circ$ и более. У сигналов с азимутальными отклонениями время распространения значительно больше (до 50—100%), чем у нормальных сигналов, распространяющихся в плоскости дуги большого круга, а их максимальная наблюдаемая частота обычно выше в $1,5-7,5$ раза. Сигналы с азимутальными отклонениями набв. часто вимой и в равноденствие. Их появление, как правило, ухудшает радиосвязь, особенно в случае применения остронав-

равленных антенн, а также за счёт замурзаний (Фединга) сигналов вследствие появления многолучёвости.

Лит.: Дополнительные энергетические потери на атмосферных радионуклидах, М., 1983; Полярная верхняя атмосфера, пер. с англ., М., 1983; Ионосферномагнитные возмущения в высоких широтах, Л., 1986; Взаимодействие в Д. В., Жеребцов Г. А., Высокоширотные геофизические явления и прогнозирование коротковолновых радионавалов, М., 1987; Физика авроральных явлений, Л., 1988. П. В. Куца.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ — относительное содержание элементов в космич. веществе. Часто под Р. з. подразумевают распространённость не только хим. элементов, но также и их изотопов по отдельности, т. е. более общее понятие — распространённость нуклидов (РН). Среднюю РН определяют по совокупности данных геохимии, космохимии и астрофизики тремя осн. методами: исследованием состава образцов земного, метеоритного и лунного вещества; изучением спектров ал.-магв. излучения Солнца, звёзд и межзвёздной среды; определением содержания нуклидов в солнечных и галактич. космических лучах.

РН в ср. быстро падает с увеличением массового числа, обнаруживая максимумы для групп С, N, O и Fe («железный пик») и затем неск. двойных пиков, соответствующих элементам Kг и Sr, Xe и Ba, Pt и Pb, k-рые имеют устойчивые изотопы с магич. числами нейтронов 50, 82, 126 (см. *Магические ядра*) либо получаются при бета-распаде ядер с такими нейтронными числами.

На рис. 2 же кривая РН приведена в более компактном виде, без разделения изотопов по процессам их образования. Эта т. н. стандартная кривая РН в Солнечной системе, построенная согласно данным А. Камерона, чётко обнаруживает указанные выше максимумы и является гл. наблюд. осн. теории нуклеосинтеза в природе. Согласно этой теории, осн. процессы образования ядер в природе включают космологич. нуклеосинтез в горячей Вселенной, приводящий к образованию гелия, термоядерное горение лёгких элементов до водорода до кремния в недрах звёзд, синтезирующие элементы «железного пика», а также процессы медленного и быстрого захвата нейтронов ядра-

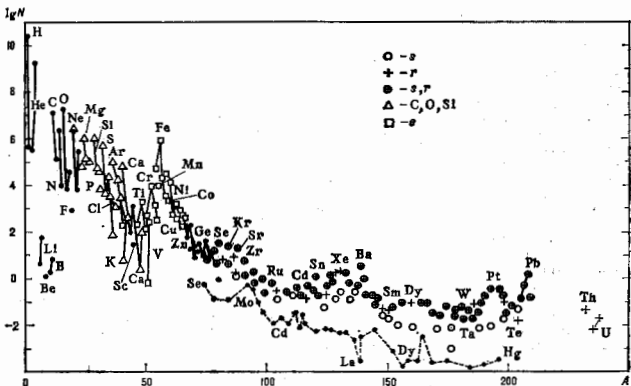


Рис. 1. Относительная распространённость нуклидов lgN (N — число атомов, $lgN_A = 8$) в зависимости от атомной массы A (по А. Камерону). Изотопы одного и того же элемента (вплоть до Be) соединены прямыми линиями. Символы указывают основные процессы синтеза нуклидов: Δ — взрывное горение С, O и Si; \square — медленный захват нейтронов (s -процесс), $+$ — быстрый захват нейтронов (r -процесс), \oplus — сравнительный вклад в r -процесс, \square — ядерное статистическое равновесие (e -процесс). Нуклиды, образовавшиеся в других процессах, отмечены точками. Штриховой линией обозначена обобщённая кривая.

Изотопный состав веществ достаточно хорошо изучен только для Солнечной системы. В Солнце заключена б. ч. массы Солнечной системы. Однако спектральный анализ содержания элементов и нуклидов в солнечной атмосфере не обладает столь большой точностью, как хим., радиохим. и масс-спектрохим. анализ состава метеоритного и планетного твёрдого вещества. Поэтому содержание нуклидов в метеоритах рассматривается в качестве стандарта при систематизации распространённости большинства элементов.

На рис. 1 в логарифмич. шкале показана РН в Солнечной системе, нормированная на содержание кремния. Приведённые данные получены в осн. из анализа состава метеоритов. Систематизация этих данных выполнена А. Камероном (А. Cameron) в 1982 (см. также табл.). Наиб. распространённость имеет водород (^1H), примерно на порядок меньше — гелий (^4He). Т. к. распространённость этих элементов вследствие их летучести на Земле, Луне и метеоритах мала, их действие, содержащееся в природе оценивают с привлечением косвенных данных: анализа внутр. строения звёзд и состава вещества межзвёздной среды, а также выводов космологич. Водород и гелий имеют в осн. первичное, космологич. происхождение (см. *Горячая Вселенная* теория). Невское содержание дейтерия и изотопов Li, Be, V объясняется тем, что эти нуклиды при звёздных темп-рах легко вступают в разл. ядерные реакци-

Распространённость некоторых нуклидов в Солнечной системе (по А. Камерону, 1982)

Нуклид	Содержание в природной смеси изотопов, %	Распространённость по числу атомов ($N_{Si} \equiv 10^6$)	Нуклид	Содержание в природной смеси изотопов, %	Распространённость по числу атомов ($N_{Si} \equiv 10^6$)
^1H	99,985	$2,68 \cdot 10^{10}$	^{82}Sr	82,56	18,9
^2H	0,015	$4,40 \cdot 10^8$	^{90}Nb	100	0,9
^3He	$1,38 \cdot 10^{-4}$	$3,2 \cdot 10^8$	^{91}Ag	51,35	0,226
^4He	~ 100	$1,8 \cdot 10^8$	^{92}Ag	48,85	0,224
^6Li	7,42	$4,45 \cdot 10^7$	^{94}Sn	23,03	0,889
^7Li	92,58	55,55	^{96}Sn	32,85	1,22
^9Be	100	1,2	^{100}Sn	100	1,27
^{10}B	80,38	7,2	^{106}Xe	27,5	1,61
^{11}B	98,89	$1,11 \cdot 10^7$	^{108}Ba	74,86	3,44
^{12}C	99,894	$2,31 \cdot 10^8$	^{109}Sm	100	0,024
^{13}C	99,759	$1,84 \cdot 10^7$	^{112}Dy	100	0,078
^{14}C	88,88	$2,31 \cdot 10^8$	^{114}Dy	0,0524	$1,93 \cdot 10^{-4}$
^{15}N	100	$8,9 \cdot 10^7$	^{116}Dy	28,18	0,104
^{16}O	78,70	$8,9 \cdot 10^8$	^{118}Dy	0,0123	$2,48 \cdot 10^{-4}$
^{17}O	100	$8,5 \cdot 10^8$	^{120}Dy	96,9877	0,020
^{18}O	92,21	$9,22 \cdot 10^8$	^{104}Ov	1,29	0,0089
^{19}F	85,0	$4,75 \cdot 10^8$	^{106}Ov	41,0	0,283
^{20}F	85,0	$8,93 \cdot 10^8$	^{108}Pt	33,8	0,477
^{21}F	96,97	$6,06 \cdot 10^8$	^{110}Pt	100	0,21
^{22}F	83,7	$1,06 \cdot 10^8$	^{112}Au	58,55	1,522
^{23}F	91,48	$6,25 \cdot 10^8$	^{114}Au	400	0,14
^{24}F	87,88	$3,4 \cdot 10^8$	^{116}Au	100	0,045
^{26}F	100	6,2	^{118}U	0,720	0,0084
^{28}F	56,90	23,5	^{120}U	99,2745	0,0203

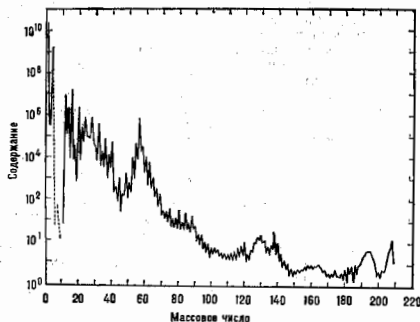


Рис. 2. Стандартная кривая распространённости нуклидов.

ми с образованием тяжёлых нуклидов вплоть до изотопов висмута и урана. Особый интерес в теории нуклеосинтеза представляет происхождение т. н. обобщённых ядер. Это изотопы Se, Mo, Cd, La, Dy и др. элементов, к-рые оказываются в стороне от путей нейтронного захвата. Распространённость обобщённых нуклидов примерно на два порядка меньше распространённости ядер, образующихся в процессах нейтронного захвата. Синтез обобщённых ядер объясняют обычно ядерными реакциями с участием протонов (p, γ), (p, n) или слабыми взаимодействиями с участием нейтрино, возникающими при взрыве сверхновой. Не исключён также вклад в механизм их синтеза тройного деления ядер с вылетом обогащённых нейтронами лёгких заряж. частиц.

Несмотря на то, что состав большинства звёзд, галактик и межзвёздной среды в осн. следует стандартной кривой РН, существуют отклонения от неё, вызванные разл. физ. причинами. Старые звёзды, принадлежащие гало Галактики и шаровым звёздным скоплениям, содержат тяжёлых элементов в 10^{-10} раз меньше, чем Солнечная система. Это связано с хим. эволюцией галактик. Нек-рые группы звёзд содержат тяжёлые элементы в пропорциях, существенно отличающихся от стандартных распространённости, таковы, напр., т. н. суперметаллич. звёзды (барневые, CNO и др.). Существуют также обогащённые и обеднённые гелием звёзды, звёзды с низким содержанием Са. Звёзды с аномальным хим. составом составляют примерно 10% всех звёзд, находящихся вблизи гл. последовательности (см. Герцишпрунг — Расселла диаграмма) и имеющих темп-ру поверхности от 8000 до 20 000 К (см. Химически неупорядоченные звёзды).

Появились свидетельства в пользу того, что изотопный состав Солнечной системы также не является столь однородным, как казалось раньше. Открыты аномалии (большинство из них на уровне долей процента) в распространённости изотопов кислорода, неона, магния. Всё это указывает на многообразие процессов, сформировавших вещество звёзд, галактик и Солнечной системы.

Лит.: Франк-Каменский Д. А., Наде́ж и Д. К., Распространённость элементов, в ян. Физика космоса, 4 изд., М., 1986; Ядерная астрофизика, пер. с англ., М., 1986; Крамаровский И. М., Чечев В. П., Синтез элементов во Вселенной, М., 1987.

РАСПЫЛЕНИЕ твёрдых тел — разрушение твёрдых тел под действием бомбардирующей их поверхности заряженных и нейтральных частиц (атомами, ионами, нейтронами, электронами и др.) и фотонами. Впервые наблюдалось как разрушение катода в газовом разряде (отсюда термин *к а т о д н о е* Р.). Продукты Р. — ато-

мы, положит. и отрицат. ионы, а также нейтральные и ионизованные атомные и молекулярные комплексы (кластеры). Скорость Р. характеризуют полным коэф. K , равным ср. числу всех частиц, испущенных мишенью, приходящихся на одну бомбардируемую частьцу, или парциальными коэффициентами. Кроме K (интегральная характеристика) процесс Р. определяется также дифференц. характеристиками: энергетич. распределением распылённых частиц, их угловым и зарядовым распределением, распределением по состояниям возбуждения, по массам и др.

Различают неск. видов Р., отличающихся механизмом процесса Р.: столкновительное (физ., или ионное, Р.), к-рое доминирует в той области энергий бомбардирующих частиц, где преобладают упругие процессы (ядерное торможение); Р. за счёт неупругих процессов — в результате возбуждения и ионизации атомов твёрдого тела; хим. Р., к-рое возникает, если падающие частицы атакуют в реакцию с атомами твёрдого тела, в результате чего на поверхности образуются летучие соединения. Возможны сочетания неск. механизмов Р.

Столкновительное распыление имеет место при передаче кинетич. энергии бомбардирующих частиц атомам мишени. Вследствие этого не-к-рые атомы приобретают энергию, превышающую энергию связи U_s поверхностных атомов и покидают мишень. При энергиях E_0 бомбардирующих частиц ниже не-к-рогого порога $E_{п.Р.}$ отсутствует ($K = 0$). Величина $E_{п.Р.}$ при нормальном падении ионов на мишень (угол падения $\theta = 0$) изменяется от $4U_s$, если массы ионов ($M_{и}$) и атомов мишени ($M_{м}$) близки ($M_{и} \approx M_{м}$), до $50 U_s$ если $M_{и} \ll M_{м}$.

По мере увеличения $E_0 > E_{п.Р.}$ коэф. K возрастает, проходит через максимум, положение к-рого зависит от комбинации частица — мишень, и убывает (рис. 1).

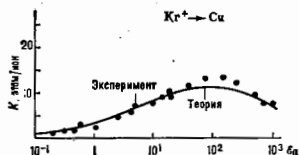


Рис. 1. Зависимость коэффициента распыления Си от энергии бомбардирующих ионов Kr^+ .

Типичные значения K — в максимуме от 10^{-2} ат/ион (лёгкие ионы) до $(1-5) \cdot 10^4$ ат/ион (тяжёлые ионы). Значимость K от атомных номеров как бомбардирующих ионов $Z_{и}$, так и атомов материала мишени $Z_{м}$ является немонотонной. В частности, зависимость от $Z_{и}$ практически такая же, как и зависимость обратной величины энергии сублимации E_s распыляемого материала (рис. 2). При столкновит. Р. под действием нейтронов $K \sim 10^{-4}-10^{-6}$ ат/ион. При увеличении угла θ падения частиц на мишень K для монокристалла и аморфных мишеней растёт, проходит через максимум ($\theta = 60-80^\circ$) и затем убывает. Для монокристалла, чья мишень на фоне возрастания K с θ наблюдается резкое его уменьшение, когда направление бомбардировки становится параллельным либо осам, либо плоскостям мишени с низкими кристаллографич. индексами (рис. 3).

Зависимость K от темп-ры T мишени обычно является слабой, если только T не близка к $T_{пл}$ материала мишени либо если в исследуемом температурном интервале мишень не претерпевает фазовых переходов. В последнем случае K может резко измениться в узком температурном интервале. Коэф. K может зависеть также и от флюенса облучения и от состояния облучаемой поверхности, в частности от размеров зёрен, текстур поверхности, шероховатости.

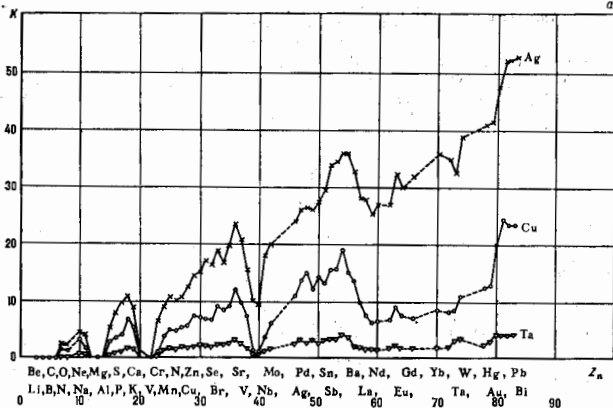


Рис. 2. Зависимость K от атомного номера иона Z_a (а), от атомного номера Z_m атома мишени (б) и зависимость обратной величин энергии сублимации ϵ_s от Z_m (в).

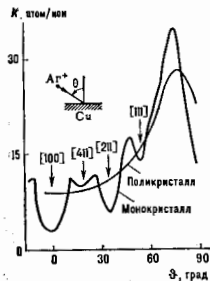


Рис. 3. Зависимость K от угла падения θ ионов на мишень.

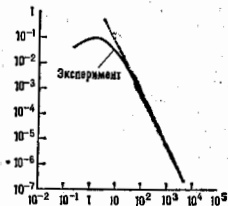
Угл. распределение вылетающих частиц в случае аморфных и поликристаллич. мишеней широко. Если энергия бомбардирующих частиц ϵ_0 не слишком мала и углы падения θ не слишком велики, то распределение слабо зависит от сорта частиц, ϵ_0 , θ , и в первом приближении число распыленных частиц $N \sim \cos \phi$ (ϕ — угол вылета относительно нормали к поверхности мишени). При высоких энергиях распределение частиц более узкое, при низких — более широкое,

чем $N \sim \cos \phi$. При увеличении θ максимум распределения сдвигается в направлении пучка бомбардирующих ионов. В случае монокристаллич. мишеней наблюдается преимуществ. выход распыленного вещества вдоль наиб. плотно упакованных направлений мишени (пяти в В е р е а).

Энергетич. распределение распыленных частиц $N(\epsilon)$ широкое. Среди распыленных частиц имеются частицы как с тепловыми энергиями ($\epsilon \sim kT$), так и с энергиями $\epsilon \sim \epsilon_0$. Максимум распределения наблюдается при $\epsilon_{\text{макс}} \sim 1-10 \text{ эВ}$; его положение зависит от энергии сублимации ϵ_s атомов мишени. При $\epsilon_s \gg \epsilon_{\text{макс}} N(\epsilon) \sim \epsilon^{-2}$ (рис. 4). Ср. энергия $\bar{\epsilon}$ распыленных частиц тем меньше, чем больше K (для монокристаллич. мишеней $\bar{\epsilon}$ зависит также от кристаллографич. направления).

При бомбардировке молекулярными ионами, а также при бомбардировке тяжёлых мишеней тяжёлыми ионами могут наблюдаться нелинейные эффекты. В частности, коэф. Р. двухатомными молекулярными ионами может превышать $2K$ для атомарных ионов той же скорости,

Рис. 4. Энергетическое распределение распыленных частиц.



а энергетич. распределение распыленных частиц может обогащаться частицами с энергиями $\epsilon \sim kT$.

В процессе Р. могут происходить изменения состава, структуры и топографии поверхности. Под действием тяжёлых ионов образуются конусы и пирамиды размером порядка мкм, гребни, канавки и ямки. При облучении лёгкими ионами в приповерхностном слое могут появляться пузырьки газа, что приводит к вспучиванию поверхности (б л и с т е р и н г у), шелушению и отслаиванию.

Теория столкновительного Р. (напр., теория Зигмунда) основаны на рассмотрении каскадов упругих столкновений, вызванных передачей кинетич. энергии от бомбардирующей частицы атомам мишени. Работают 3 режима столкновительного Р. Ре ж и м 1 в я р я м о г о в ы б и в а я и реализуется вблизи порога ϵ_{01} при бомбардировке лёгкими ионами и при скользящем падении; протяжённые каскады невелики, значит, вклад дают первично выбитые атомы (рис. 5). Ре ж и м л и в е й ш ы х к а с к а д о в (реализуется для всех ионов, кроме самых тяжёлых — с энергиями ϵ_0 от 1 до неск. десятков кэВ и для нейтронов) характеризуется малой плотностью распределения выбитых атомов, так что преобладают столкновения движущихся атомов с неподвижными, а столкновения движущихся



Рис. 5. Режимы столкновительного рассеяния.

атомов между собой происходит редко. В режим и в линейных каскадах (тепловых шагов) реализуется для ионов с большими массами и молекулярных ионов. Плотность распределения вбитых атомов столь высока, что большинство атомов внутри некоторого объема находится в движении.

Каскадные теории для Р. твёрдых тел с неупорядоченным расположением атомов в режиме линейных каскадов, основанные на уравнении Больцмана, приводят к соотношениям

$$K \sim (d\sigma_{ij}/dx)_{\text{яд}}; N(\varphi) \sim \cos \varphi; N(\delta) \sim \delta^{-2}.$$

Р. за счёт упругих столкновений наб. существенно в металлах и полупроводниках.

Электронный механизм рассеяния реализуется, если кинетич. энергия иона (электрона, фотона) расходуется на изменение внутр. энергии атома мишени. Наблюдается для диалектриков (щелочно-галогенные соединения, органич. соединения, отвержденные газы, лёд, большие биомолекулы), а также для ряда полупроводниковых соединений и мелкодисперсных металлов. Коэф. K могут достигать значений $10^2 - 10^4$ ат/ион. Энергетич. зависимость $K(\mathcal{E}_i)$ имеет максимум в области максимума неупругих уд. потерь энергии (электронное торможение). В зависимости от сочетания ион (электрон) — мишень наблюдается либо прямая пропорциональная, либо более сильная — вплоть до квадратичной — зависимость K от $(d\mathcal{E}/dx)_{\text{эл}}$. Величина K не зависит от T вплоть до опред. пороговой темп-ры, после чего наблюдается рост K при приближении к темп-ре, при к-рой происходит либо сублимация мишени, либо разрыв молекулярных связей). Энергетич. распределение рассеянных частиц значительно более узкое, максимум наблюдается при энергиях, значительно более низких, чем в случае столкновительного Р.

При Р. под действием низкоэнергетич. электронов и фотонов пороговая энергия \mathcal{E}_p того же порядка, что и ширина запрещённой зоны \mathcal{E}_g мишени и энергия экзитонных переходов. Р. может быть эффективным лишь для к-л. одного элемента соединения, напр. галогена в щелочно-галогидном соединении. При облучении фотонами число рассеянных частиц N растёт с ростом интенсивности облучения. Угл. распределение рассеянного вещества может различаться для разных компонентов. Так, для щелочно-галогенных соединений наблюдается преимущественное Р. галогенов вдоль низкосимметрич. осей кристалла, тогда как распределение атомов щелочного металла $N \sim \cos \varphi$. Большая доля рассеянных частиц обладает тепловыми энергиями, но есть и сверхтепловая компонента.

Единой теории преобразования энергии возбуждённого или ионизов. атома твёрдого тела в кинетич. энергию движения атомов, приводящего к Р., пока нет. Существует лишь ряд моделей (модель теплового пика, модель кулоновского вярва, аксонатная модель и др.), объясняющих те или иные закономерности сочетания бомбардирующих частиц и типа рассеяемых материалов.

Химическое рассеяние. При хим. Р. между бомбардирующими частицами и атомами мишени на поверхности

в результате хим. реакции образуются молекулы с низкой энергией связи, к-рые могут десорбироваться при темп-ре мишени. Хим. Р. наблюдается в нек-ром температурном интервале. В этом интервале зависимость $K(T)$ обычно проходит через максимум; чётко выраженной пороговой энергии нет. Коэф. K зависит от конкретного сочетания химически активных ион — мишень. Энергетич. распределение молекул в большой степени определяется темп-рой поверхности мишени.

Р. используется для получения атомно-чистых поверхностей, тонких плёнок, анализа поверхностей, при ионно-лучевой и ионно-плазменной обработке поверхностей. Р. лежит в основе ионно-плазменных способов травления материалов для целей микроэлектроники, играет важную роль в космич. материаловедении, в акустике, в технике ядерных реакторов (Р. под действием нейтронов) и термоядерных устройств, при консервации радиоакт. отходов и др.

Лит.: Рассеяние твёрдых тел ионной бомбардировкой, под ред. Р. Бершта, пер. с англ., в. 1—2, М., 1984—86; Плазменная технология в производстве СБИС, под ред. Н. Айснпрука и Д. Брауна, пер. с англ., М., 1987; Scattering by particle bombardment, ed. by R. Behrisch, K. W. Wittpack, Springer-Verl., 1991; Фундаментальные и прикладные аспекты рассеяния твёрдых тел. Сб. ст., пер. с англ., М., 1989; Фальконе Д., Теория рассеяния, «ФЭН», 1992, т. 162, № 10 с. 71; Е. С. Милославский, В. А. Мельников.

РАССЕЯНИЕ ВОЛН — возмущения волновых полей, вызываемые неоднородностями среды и помещёнными в эту среду рассеивающими объектами. Допустимо различать три осн. вида рассеяния.

1. Р. в на одиночных объектах в однородной среде. Это могут быть одиночные частицы (электроны, атомы, молекулы) в вакууме. Др. тип таких объектов — макроскопич. тела, отличающиеся от окружающей среды показателем преломления и импедансом, плазменные струйки, газовые пузырьки в жидкости и т. д. (см. *Рассеяние света*, *Рассеяние звука*). Фактически в этих случаях Р. в отличие от дифракции волн только терминологически.

2. В случае множеств. объектов или регулярных непрерывно распределённых возмущений среды особое значение имеют коллективные эффекты, обусловленные суперпозицией полей рассеяния и взаимным перераспределением (многократным рассеянием). Так формируются диаграммы рассеяния от периодич. решёток, многослойных структур (см. *Дифракционная решётка*, *Брэгговское отражение*). В нелинейных средах такие (как правило, периодические) структуры образуются как отклики среды на интенсивные волны накачки или на разл. суперпозиции полей в многоволновых комбинациях. Эти случаи относятся к явлениям вынужденного Р. в. (см., напр., *Мандельштам — Брэгговское рассеяние*).

3. Р. в стохастических (случайно распределённых) возмущениях сред или границ раздела. Иногда под Р. в. понимается именно такой тип рассеяния. Если облако дискретных хаотических расположенных рассеивателей достаточно разрежено, при расчёте рассеянных полей можно пользоваться приближением однократного рассеяния, т. е. первым приближением метода возмущений (см. *Ворновское приближение*, *Возмущений теория*). Это приближение справедливо в условиях, когда ослабление падающей волны из-за перехода части её энергии в рассеяние поле незначительно. В этом случае диаграмма направленности рассеяния плоской волны от всего облака рассеивателей совпадает с *индикатрисой* рассеяния отд. частицы. При наличии движения рассеивателей частотный спектр рассеяния первоначально монохроматической волны изменяется: ср. скорость движения рассеивателей определяет сдвиг максимума спектра, а дисперсия её флуктуаций — уширение спектра рассеянного волнового излучения в соответствии с *Доплеровским эффектом*. При рассеянии эл.-магн. волны происходит также изменение поляризации.

При большой концентрации рассеивателей в среде происходит многократное Р. в. на частицах. В этом случае падающая волна сильно затухает из-за рассеяния даже

в отсутствие истинной диссипации, а угловой и частотный спектры рассеянного излучения изменяются по мере проявления в глубь рассеивающей среды. При анализе используются теория *переноса излучения*, имеющая дело с интенсивностями распространяющихся волн, и теория многократного рассеяния, основанная на решении волнового уравнения с учётом эффектов взаимодействия мн. частей.

В реальных хаотически неоднородных сплошных средах флуктуации их параметров (концентрация, темп., скорости движения и т. д.), как правило, являются достаточно слабыми. Это позволяет при расчёте R_v на неоднородностях, находящихся в достаточно малом объёме, использовать приближение однократного рассеяния. В этом случае угл. спектр рассеянного излучения повторяет пространственный спектр неоднородностей среды, поскольку процесс рассеяния под данным углом можно представить как брэгговское отражение от одной из пространственных гармоник среды (трёхмерных решёток), определяемой разностью волновых векторов падающей и рассеянной волн. В турбулентных потоках частотный спектр рассеяния определяется, как и для дискретных рассеивателей, ср. и флуктуац. скоростями макроскопич. движения среды.

Теория многократного рассеяния в сплошных средах наиб. хорошо развита для случая одномерных неоднородностей, а в трёхмерно-неоднородных средах — в приближении малогоуглового рассеяния «всперёд». Для анализа используется схема *марковских случайных процессов* в диффузионном приближении, теория *переноса излучения*, метод суммирования ряда теории возмущений по кратности рассеяния при помощи *фейнмановских диаграмм* (решения *Дайсона уравнения и Бете — Салпитера уравнения*), метод геом. оптики, *плазмы возмущений метод и параболическое уравнение приближения*. Одним из наиб. ярких эффектов многократного рассеяния в одномерной среде является полное отражение волны от полубесконечной среды со слабыми флуктуациями показателя преломления. При маломуголом многократном рассеянии в среде с трёхмерными неоднородностями происходит накопление флуктуаций параметров волны с ростом дистанции. В частности, накопление с расстоянием флуктуаций направления нормали к поверхности пост. фазы волны приводит к росту ширины угл. спектра излучения. В среде с пространственно-переменными неоднородностями аналогичным образом растёт с расстоянием ширина частотного спектра. Дисперсия флуктуаций интенсивности на нек-рой глубине выходит на стационарный уровень. Совместное влияние диссипации и рассеяния приводит к существованию «глубинного режима», когда угл. спектр излучения перестаёт зависеть от диаграммы направленности падающей волны.

Важную в прикладном аспекте роль играет R_v в равновесной и неравновесной плазме, где наряду с эл. магн. волнами могут распространяться и др. типы волн (плазменные) в изотропич. плазме, ионно-звуковые в неадиабатической, альвеновские, магн.-звуковые и свистовые в магнитоактивной плазме и т. п., см. *Волны в плазме*. Это приводит к очень сложной картине рассеяния, существенно меняемому как угловому, так и частотному спектров, трансформации волны одного типа в другие и т. п.

R_v на шероховатых и неоднородных поверхностях раздела сред приводит к тому, что волна не только отражается в зеркальном направлении, но и рассеивается в др. направлениях. Если шероховатая поверхность движется, то спектр рассеянной волны отличен от спектра падающей волны. Такие характеристики, как интенсивность и поляризация рассеянных волн, видяктриса рассеяния, существенно зависят от соотношения между длиной волны, масштабом и высотой шероховатостей. Осн. методами для расчёта поля рассеяния на шероховатых поверхностях являются метод возмущений и *Кирхгофа метод*. Метод возмущений справедлив, когда

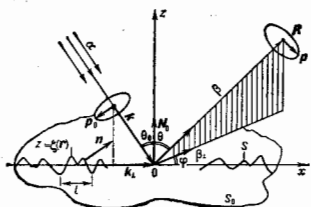
высота шероховатости мала по сравнению с длиной волны, а метод Кирхгофа пригоден для сколь угодно высоких, но плавных неровностей. Дальнейшая разработка теории велась по линии развития приближений малых возмущений и метода Кирхгофа. Вводились нелокальные граничные условия, учитывались затенения в методе Кирхгофа, развивалась концепция резонансного рассеяния, разрабатывалась теория рассеяния на поверхности с двумя типами неровностей и т. д.

Теория R_v имеет важное прикладное значение. Напр., ежк. Дрэйл (J. Rayleigh) в развитой им теории рассеяния света на тепловых флуктуациях показателя преломления воздуха установил, что интенсивность рассеянных волн растёт пропорционально 4-й степени частоты. Это позволило ему объяснить голубой цвет неба. Дисперсией света и рассеянием на водяных капелках воздуха после дождя объясняется явление радуги. Рассеяние радиоволн на шероховатых поверхностях привлекается для определения параметров шероховатости морской поверхности, поверхности Луны и планет и т. д. R_v в связанных с ним флуктуациях параметров волн широко используются для создания дистанц. методов измерения характеристик турбулентных потоков, атмосферной турбулентности, лабораторной и ионосферной плазмы. Изменение направления волн при рассеянии в тропосфере и ионосфере используется для создания систем *аэрозонитной радионавигации* на УКВ (см. *Аэрозонитное распространение радиоволн*).

Лит.: Басс Ф. Г., Фунс И. М., Рассеяние волн на статистически неровой поверхности, М., 1972; Электродинамика плазмы, М., 1974; Введение в статистическую радиофизику, ч. 2 — Рытов С. М., Крайнов Ю. А., Татарский В. И., Случайные поля, М., 1978; Кляцкин В. И., Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах, М., 1980; Исмаилов А., Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, пер. с англ., т. 1—2, М., 1981; Ахманов С. А., Дьяков Ю. Е., Черныш А. С., Введение в статистическую радиофизику и оптику, М., 1981.

В. В. Тамойкин, В. Г. Гаверзиенко.

РАСSEЯНИЕ ВОЛН НА СЛУЧАЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ — рассеяние волн на статистически неровой границе раздела двух сред. R_v на с. п. оказывает существенное влияние на характер распространения радиоволн в естеств. условиях: рассеяние на неровностях рельефа земной поверхности, взволнованной поверхности моря, ниж. границе ионосферы приводит к флуктуациям параметров радиосигналов. При передаче сигналов по волноводным или квазиволнч. линиям передачи шероховатости поверхности является причиной появления паразитных мод, искажения передаваемых сигналов и их затухания. При работе радиолокац. и радиометрич. систем R_v на с. п., с одной стороны, является источником пассивных помех, маскирующих полезный сигнал, а с другой — содержит полезную информацию о параметрах рассеивающей поверхности, являясь физ. основой методов дистанц. зондирования окружающей среды, напр. для определения по радиолокац. (радиометрич.) данным параметров морского волнения, состояния ледового и снежного покрова, степени расчленённости рельефа и т. д. В задачах гидро- и сейсмоакустики аналогичную роль играет рассеяние звука на поверхности и дне океана, на др. границах раздела сред с различающимися физ. параметрами. В оптике R_v на с. п. приводит к нарушению законов зеркального отражения и преломления, является причиной искажений изображения в реальных оптич. системах и диффузного рассеяния света разл. матовыми поверхностями. В физике твёрдого тела рассеяние разл. квазичастиц, траекторных как волны, на естеств. шероховатой поверхности образца приводит к уменьшению времени их жизни, затуханию собств. состояний (напр. магн. поверхностных урней), влияет на характер скин-эффекта и др. кинетич. явлений (алектро- и теплопроводность тонких плёнок, расширение линий резонансных переходов между разл. квантовыми состояниями и т. д.).



Отклонения неровной поверхности S (рис.) от ср. плоскости $z = 0$ описываются случайной ф-цией $z = \xi(r)$, где $r = (x, y)$, усреднение по ансамблю реализаций этой ф-ции обозначается $\langle \dots \rangle$. Скалярное волновое поле $U(R, t)$, $R = (r, z)$ (либо любая компонента векторного) в результате Р. в. на с. п. также становится случайным и может быть представлено в виде суммы среднего (когерентного) поля $\langle U \rangle$ и флуктуационного (некогерентного) поля u . Для описания Р. в. на с. п. в качестве неровного поля достаточно, в силу принципа суперпозиции, рассмотреть плоскую монохроматич. волну $U_0 = \exp[i(kR - \omega t)]$ с волновым вектором k и частотой ω , падающую из верх. полупространства под углом θ_0 на границу раздела двух сред. Ниже описываются только отраженные волны, рассеянные в верх. подпространство. Для решения задачи о Р. в. на с. п. использую след. приближенные методы.

Метод малых возмущений (ММВ) применяют для достаточно низких и пологих неровностей:

$$P = (2ka \cos \theta_0)^2 \ll 1, \quad \gamma_0^2 = \langle (\xi^2) \rangle = \sigma^2 / l^2 \ll 1.$$

Здесь P — параметр Рэлея, $\sigma^2 = \langle \xi^2 \rangle$ — дисперсия высот неровностей, l — их радиус корреляции, γ_0^2 — дисперсия наклонов. При скользящем распространении ($\theta_0 \rightarrow \pi/2$) вместо P следует требовать малости параметра Фейнберга: $ka^2/l \ll 1$. Рассеянное волновое поле U представляется в виде ряда $U = U_0 + u_1 + u_2 + \dots$, где U_0 — отражённое (предлобное) поле на плоской границе ($\xi = 0$), а $u_n \sim \xi^n$ — малые поправки к U_0 . Если ограничиться только первыми двумя слагаемыми в ряде ММВ, то ср. поле $\langle U \rangle$ совпадает с невозмущённым U_0 , а флуктуац. поле u — однократно рассеянным полем u_1 (борновское приближение).

Рассеивающие свойства неровной поверхности характеризуют уд. эфф. поверхность σ рассеяния $\tilde{\sigma}(\alpha, \beta)$, k -рал определяется как умноженное на 4π отношение ср. потока энергии флуктуац. поля u , рассеянного с единицы площади S_0 в единичный телесный угол в направлении β , к плотности потока энергии в падающей волне, распространяющейся в направлении $\alpha = k/k$:

$$\tilde{\sigma}(\alpha, \beta) = 4\pi \langle |u(R)|^2 \rangle R^2 / |U_0|^2 S_0 = 16\pi k^4 Q(\alpha, \beta) S_\xi(q_1). \quad (1)$$

Здесь R — расстояние от центра рассеивающей площадки S_0 до точки наблюдения R , находящейся в дальнейшей зоне (зоне Фраунгофера): $q = k\beta - \alpha$ — вектор рассеяния, q_1 — его проекция на плоскость $z = 0$, $S_\xi(q)$ — пространств. спектральная плотность неровности, связанная преобразованием Фурье с их корреляционной функцией $W(\rho) = \langle \xi(r + \rho)\xi(r) \rangle$, для пространственно однородной статистически неровной поверхности

$$S_\xi(q) = (2\pi)^{-2} \int d\rho W(\rho) \exp(iq\rho).$$

Явный вид не зависящего от параметров неровностей множителя $Q(\alpha, \beta)$ определяется конкретными условиями. Напр., при рассеянии звука на абсолютно мягкой поверхности ($U|_S = 0$)

$$Q(\alpha, \beta) = (\alpha_1 \beta_1)^2 = \cos^2 \theta_0 \cos^2 \theta; \quad (2)$$

на абсолютно жёсткой поверхности ($\partial U / \partial n|_S = 0$)

$$Q(\alpha, \beta) = (1 - \alpha_1 \beta_1)^2 = (1 - \sin \theta_0 \sin \theta \cos \varphi)^2,$$

здесь φ — угол между плоскостью падения (α, N_0) и плоскостью рассеяния (β, N_0), N_0 — орт вдоль осн Oz . При рассеянии эл.-магн. волны на идеально проводящей поверхности

$$Q(\alpha, \beta) = [p_z \alpha_z (p_0 \beta) + p_{0z} \beta_z (p \alpha) + p_{0z} p_z (1 - \alpha \beta) - \beta_z \alpha_z (p \rho)]^2,$$

где p_0, p — единичные векторы поляризации падающей волны и примикания, ортогональные к направлению распространения волн: $(p_0 \alpha) = (p \beta) = 0$. При обратном рассеянии $\beta = -\alpha$ (в радиолокации) на неровной границе раздела двух сред с диэлектрич. проницаемостями $\epsilon_1 = 1$ и $\epsilon_2 = \epsilon$:

$$Q(\alpha, -\alpha) = (1/16) \{ (\epsilon - 1)(1 + V_r) + [1 + V_r (p \rho) + (\epsilon - 1) \epsilon^{-1/2} - V_r^2] p_z p_{0z} \}^2.$$

Здесь $V_{rH}(\theta_0)$ — коэф. отражения Френеля для горизонтальной (H) и вертикальной (V) поляризации (см. Френеля формул).

Р. в. на с. п. в борновском приближении, как следует из ф-лы (1), является резонансным: в направлении β рассеивает только одна пространств. гармоника из спектра $S_\xi(q_1)$ неровности поверхности, волновой вектор k -рал совпадает с проекцией вектора рассеяния q на плоскость $z = 0$.

Модифицированная теория возмущений (МТВ) учитывает при расчёте ср. поля $\langle U \rangle$ многократное рассеяние. Отражение ср. поля $\langle U \rangle$ от случайной поверхности происходит так же, как и от плоской границы раздела $z = 0$, во с эфф. поверхностью импеданса $\eta(k_1)$, зависящим от длины волны λ и направления облучения, т. е. при Р. в. на с. п. имеет место дисперсия пространственная. Для абсолютно жёсткой поверхности $\eta(k_1)$ выражается через интеграл по всем направлениям рассеяния β от величины $\tilde{\sigma}(\alpha, \beta)$, аналитически продолженной в область комплексных углов рассеяния θ ($\sin \theta = |\beta| = |\alpha|/k > 1$):

$$\eta(k_1) = k^{-1} \int d\alpha \alpha^{-1} (k^2 - \alpha^2)^{-1/2} S_\xi(\alpha - k_1) = (1/16\pi) \int d\beta \beta_z^{-1} \tilde{\sigma}(\alpha, \beta), \quad (2)$$

где $\alpha_z = \sqrt{k^2 - \alpha^2}$, $\beta_z = \sqrt{1 - \beta^2}$ ($\text{Im} \alpha_z, \text{Im} \beta_z \geq 0$). Активная часть импеданса $\text{Re} \eta(k_1)$ пропорциональна энергии, рассеянной во флуктуац. поле, и определяется интегралом (2) только по вещественным углам рассеяния ($|\beta| \leq 1$), рассеяние происходит в однородные уходящие от поверхности волны; реактивная часть $\text{Im} \eta(k_1)$ связана с рассеянием в неоднородные волны ($|\beta| > 1$), обусловлены сдвиг фаз между падающей и отраженной волнами и замедление поверхностных волн, распространяющихся над шероховатой жёсткой поверхностью.

При рассеянии эл.-магн. волн статистически неровная поверхность по отношению к когерентному полю эквивалентна импедансной, вообще говоря, анизотропной плоскости, описываемой тензором поверхностного импеданса $\eta_{\nu\mu}$; $\mu, \nu = x, y$, связывающего тангенц. компоненты ср. элктрич. E и магн. H полей:

$$E_\nu = \eta_{\nu\mu} N_\mu J_\nu,$$

для идеально проводящей поверхности ($|\epsilon| \rightarrow \infty$)

$$\eta_{nm}(k_1) = k^{-1} \int dx_2 \int dx_3 \left[x_2^2 (\delta_{nm} k^2 - k_n k_m) + k^2 (k_n - x_n)(k_m - x_m) \right] \delta(\xi |k - k_1|).$$

При рассеянии волн на изменяющейся во времени границе раздела, возмущения k -рой можно представить в виде суперпозиции бегущих плоских волн с волновыми векторами p и частотами $\Omega(p)$, происходит изменение частоты рассеянных волн по сравнению с частотой падающей волны ω . В борновском приближении спектр рассеянного поля в зоне Фраунгофера состоит из двух комбинац. частот:

$$\omega_{\pm} = \omega \pm \Omega(q_1).$$

Затухание поверхностных волн $|\text{Im}\Omega(p) \neq 0|$, а также след. порядки в ММВ отражаются в расширении спектра рассеянного поля и появлении др. комбинац. частот.

В ближней зоне (зоне Френеля) интерференция рассеянных волн приводит к флуктуациям амплитуды и фазы волнового поля, характер k -рых определяется значением волнового параметра $D = R/k^2 \cos \theta_0$, равного по порядку величины ср. числу вершинностей в первой зоне Френеля; при $D \ll 1$ — флуктуации амплитуды малы, а дисперсия флуктуаций фазы равна параметру Рэлея P ; при $D \gg 1$ — флуктуации амплитуды и фазы некогерентны, а их дисперсии совпадают и равны $P/2$.

Метод касательной плоскости (МКП), или метод Кирхгофа, применяют для решения задач о Р. в. на с. п. с большими по сравнению с λ вершинностями. При этом допустимы сколь угодно большие значения параметра Рэлея, однако вершинности должны быть достаточно гладкими — $\text{kacos}^2 \theta' \gg 1$, где α — характерный радиус кривизны поверхности, а θ' — локальный угол падения, $\text{cos} \theta' = -(\pi \alpha)$. В основе МКП лежит предположение о том, что поле U в каждой точке R_0 поверхности S можно представить в виде суммы волн падающей волны и волн, зеркально отраженной от плоскости, касательной к поверхности в точке R_0 ; поле в произвольной точке R затем определяют по Грина формуле в соответствии с принципом Гюйгенса — Френеля. После усреднения по ансамблю реализаций $\xi(r)$ когерентное поле $\langle U \rangle$ распространяется только в направлении зеркального отражения от ср. плоскости $z = 0$, отличаясь от поля нулевого приближения U_0 на эфф. коэф. отражения V_0 :

$$\langle U \rangle = V_0 U_0; \quad V_0 = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi w(\xi) \exp(-2i k \xi \cos \theta_0), \quad (3)$$

$w(\xi)$ — плотность распределения вероятности случайных отклонений ξ от ср. плоскости $z = 0$. Для нормальной случайной поверхности, отклонения k -рой от ср. плоскости соответствуют Гауссу распределению, $V_0 = \exp(-P/2)$.

Некогерентное рассеяние в заданном направлении при больших значениях параметра Рэлея определяется вероятностью зеркально отражающих из α в β наклонов поверхности $\gamma_3 = -q_1/q_2$ (с нормалью $n_3 = q/q_0$):

$$\tilde{\sigma}(\alpha, \beta) = \pi |V(\theta_3)|^2 (q_1/q_2) w_r(\gamma_3), \quad (4)$$

где w_r — плотность распределения вероятностей наклонов γ — $V(\theta_3)$ — коэф. отражения Френеля при зеркальных углах падения, $\text{cos} \theta_3 = (n_3/\beta) = -(\pi_3/\alpha)$.

Учет затенений поверхности в рамках МКП сводится к тому, что в ф-лах (3) и (4) под ф-циями $w(\xi)$ и w_r следует понимать плотности распределения высот и накло-

нов только освещенных (по отношению к направлениям α и β) участков поверхности. Величина $\tilde{\sigma}$ в форме (4) не зависит от длины волны излучения и по сути является следствием применения геометрической оптики метода. Расчет дифракц. эффектов приводит к поправкам к МКП $\sim \sigma^2/k^2$, а для эл.-маг. волн в радио-диапаз. случае ($\beta = -\alpha$) — к появлению деполяризации рассеянного поля, что не удаётся выявить в рамках ММВ и МКП.

Двухмасштабную модель (ДММ) применяют для интерпретации эксперим. данных по Р. в. на с. п. с широким спектром вертикальных и горизонтальных масштабов неровностей, когда не выполняются условия применимости ни ММВ, ни МКП. Шероховатую поверхность в ДММ рассматривают как суперпозицию мелкомасштабной «ряби» (для расчёта рассеяния на k -рой применим ММВ) и гладких крупномасштабных вершинностей $z = Z(r)$ с наклонами $\Gamma = \nabla Z$, удовлетворяющими МКП. В результате $\tilde{\sigma}$ представляется в виде суммы (4) (где следует заменить γ на Γ) и усреднённой по наклонам крупномасштабной поверхности Γ величины $\tilde{\sigma}_N(\alpha, \beta)$, рассчитанной по ф-ле (1) для шероховатой плоскости со ср. неровности $N = (N_0 - \Gamma)(1 + \Gamma^2)^{-1/2}$:

$$\tilde{\sigma}(\alpha, \beta) = \int d\Gamma w(\Gamma) N^2 \tilde{\sigma}_N(\alpha, \beta),$$

где $w(\Gamma)$ — плотность распределения вероятностей наклонов Γ . С помощью ДММ описывают рассеяние радиоволн возвышенной морской поверхностью и поверхность Луны, рассеяние звука поверхностью и дном океана.

Метод малых наклонов (ММН) применяют для расчёта Р. в. на с. п. с вершинностями произвольной высоты, но достаточно пологими ($\gamma' \ll 1$). Для низких вершинностей ММН приводит к ф-лам ММВ, для высоких — к МКП. Первый член ряда по γ_0 получается из ф-лы (1) борновского приближения для $\tilde{\sigma}$ (определённого для полного рассеянного поля, а не только флуктуационного) заменой:

$$S_1(q_1) \rightarrow (2\pi q_2)^{-2} \int d\rho \exp(iq_1 \rho - q_2^2 D_1(\rho)/2),$$

где $D_1(\rho) = \langle [\xi(r + \rho) - \xi(r)]^2 \rangle$ — структурная ф-ция вершинностей нормальной (гауссовой) поверхности. Учёт когерентности волн, испытывающих многократные рассеяния на сильношероховатой поверхности и распространяющихся в противоположных направлениях по одним и тем же траекториям, приводит к явлению усиления обратного рассеяния, аналогичного тому, k -рое имеет место при рассеянии волн на объёмных неоднородностях. См. также Дифракция волн, Рассеяние звука, Рассеяние света.

Лит.: Стрэтт Дж. В. (лорд Рэлея), Теория звука, пер. с англ., 2 изд., т. 2, М., 1955; Фейнберг Э. Л., Распространение радиоволн вдоль вейной поверхности, М., 1961; Васс Ф. Р., Фукс И. М., Рассеяние волн на статически неровной поверхности, М., 1972; Шмелев А. В., Рассеяние волн статически неровными поверхностями, «УФН», 1972, т. 106, с. 439; Введение в статистическую радиофизику, к. 2 — Рытов С. М., Бравцов Ю. А., Титарский В. И., Слуцкие поля, М., 1978, гл. 9; Исимару А., Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, пер. с англ., т. 2, М., 1981, гл. 21; Бреховский Л. М., Лысенков Ю. П., Теоретические основы акустики океана, Л., 1982, гл. 10.

РАССЯЕНИЕ ЗВУКА — рассеяние звуковых волн на пространственно-временных флуктуациях плотности и упругости реал. сред (напр., на поверхности океана, на неровном и неоднородном его дне, на пересечённой местности, на искусств. периодич. структурах и неоднородных поглощающих поверхностях, применяемых для улучшения акустич. свойств больших помещений, на дискретных неоднородностях — воздушных пузырьках в жидкости, твёрдых взвешенных частицах в жидкости или газе, на рыбах и макропланктоне в океане,

капля дождя в воздухе, точечных дефектах в кристаллах и др.). Поскольку при Р. з. часть акустич. энергии уходит по направлениям, отличным от направления распространения звука, интенсивность первичной волны уменьшается. Если при распространении в данном направлении звук рассеивается многократно, то наблюдается аксонция, ослабление его интенсивности с расстоянием.

Рассеивающую способность неоднородностей характеризуют по поперечным сечениям рассеяния σ и σ_0 , равным отношению акустич. мощности W_2 рассеянной в единицу телесного угла, к интенсивности падающей волны I_1 : $\sigma = W_2/I_1$. Значение σ_0 существенно зависит от частоты и угла падения звуковой волны, размеров неоднородностей и их акустич. характеристик. Если длина волны звука мала по сравнению с линейным размером рассеивающего тела, то сечение рассеяния σ_0 по порядку величины равно площади поперечного сечения тела, перпендикулярного направлению падения первичной волны. Для малых препятствий $\sigma_0 \sim (ka)^4$ (закон Рэлея), где k — волновое число звука, a — линейный размер тела. Весьма эфф. рассеивателями являются «резонансные» пузырьки газа в жидкости, частота собственных радиальных колебаний n -рых совпадает с частотой звуковой волны. При этом σ_0 во много раз превышает геом. сечение пузырьков. Так, напр., полное значение σ_0 (соответствующее рассеянию в телесный угол 4π) для воздушного пузырька в воде при атм. давлении на резонансе, т. е. при $ka = 0,014$, равно $4\pi/k^2$ и, следовательно, превышает геом. сечение пузырьков πa^2 в $4/(ka)^2 \approx 20000$ раз. Из-за вязкости и теплопроводности реальное значение σ_0 может существенно уменьшаться. Однако даже в случае относительно больших различий в размерах пузырьков резонансное рассеяние играет доминирующую роль (как, напр., при Р. з. в приповерхностном пузырьковом слое в океане). Аналогично Р. з. глубоководными океанич. звуко рассеивающими слоями обусловлено в осн. резонансными колебаниями плавательных пузырей небольших рыб.

Р. з. в кристаллах происходит на примесях, точечных дефектах, дислокациях, плоскостях двойникового и т. п. Если на длине звуковой волны имеется большое число точечных дефектов и примесей, то осн. роль начинает играть рассеяние на флуктуациях их числа. В поликристаллах большая вклад в Р. з. дают границы зёрен.

Наиб. значение в гидроакустике имеет Р. з. на поверхности океана, на объёмных неоднородностях водной толщи, на неровностях донного рельефа и неоднородностях подводного грунта. В результате Р. з. возникает поверхностная, объёмная и донная резервация, к-рая является одной из осн. помех при работе разл. гидроакустич. приборов и устройств. Характер Р. з. на случайных неровных поверхностях, таких, как поверхность океана, зависит от величины параметра Рэлея $P = 2k\delta\cos\theta_0$, где k — средневзвешенное значение высоты неровностей, θ_0 — угол падения первичной волны. При $P \ll 1$ Р. з. является резонансным или вибраторным — значение σ_0 определяется всего лишь одной гармоникой из сплошного пространственного спектра неровностей, волновой вектор k -рой q удовлетворяет условию Брэгга: $q = k_x - k_0$, где k_x — горизонтальные компоненты волновых векторов падающей и рассеянной волн соответственно. Если, кроме того, горизонтальный масштаб (радиус корреляции) неровностей ρ_0 мал по сравнению с длиной волны звука ($k\rho_0 \ll 1$), то частотная зависимость σ_0 следует закону Рэлея, а зависимость σ_0 от угла рассеяния θ (индикатриса рассеяния) — закону $\sigma_0 \sim \cos^2\theta$. При крупномасштабных неровностях ($k\rho_0 \gg 1$) частоты и угл. характеристики σ_0 существенно зависят от вида пространственного спектра неровностей. Так, при гауссовом спектре индикатриса рассеяния имеет режкий максимум в направлении зер-

кального отражения с угл. шириной $\Delta\theta \sim 1/k\rho_0$. В случае спектра, характерного для развитого ветрового волнения, индикатриса рассеяния имеет две максимумов разл. величины, смещённых в разные стороны относительно зеркального направления, а в направлении зеркального отражения у неё наблюдается глубокий провал.

При Р. з. на крупных плавных неровностях ($P \gg 1$) поперечное сечение рассеяния σ_0 пропорц. плотности вероятности наклонов неровностей и не зависит от частоты звука; индикатриса рассеяния при этом имеет максимум в зеркальном направлении с угл. шириной, пропорциональной средневзвешенному значению наклонов неровностей. При Р. з. на неровных поверхностях со сложным спектром неоднородностей рассеянное поле в направлениях, близких к направлению зеркального отражения, определяется в основном крупномасштабными компонентами неровностей, а поле в обратном (локационном) направлении обусловлено гл. обр. мелкомасштабными неровностями.

Р. з. на слабых флуктуирующих показателя преломления в атмосфере или океане во многом аналогично Р. з. на малых случайных неровностях. Оно также имеет резонансный характер; длина волны «резонансной» гармоникой $\lambda = \lambda_0/\sin(\theta/2)$, где λ_0 — длина волны звука, θ — угол между волновыми векторами падающей и рассеянной волн. По мере уменьшения θ рассеяние определяется неоднородностями всё больших масштабов. При рассеянии в обратном направлении $\lambda = \lambda_0/2$.

Временная изменчивость рассеивателей приводит к расширению частотного спектра рассеянного поля. Типичным примером может служить Р. з. на взволнованной морской поверхности и внутр. волнах в атмосфере и океане. Ряд особенностей имеет Р. з. на дне океана. В мелководных районах Р. з. обусловлено гл. обр. флуктуирующими показателя преломления и плотности в толще подводных осадков. В широком диапазоне частот (1—100 кГц) σ_0 для рассеяния в обратном направлении не зависит от частоты звука, его угл. зависимость близка к закону Ломмеля — Зеллера $\sigma_0 \sim \cos^2\theta$. В глубоком океане осн. вклад в Р. з. дают неровности донного рельефа.

Анализ разл. характеристик рассеянного звукового поля позволяет определять разл. характеристики самих рассеивателей. Так, напр., по обратному рассеянию звука на турбулентных неоднородностях в атмосфере находят структурный спектр пульсаций показателя преломления. Наличие Р. з. на неоднородностях и дефектах в твёрдых телах лежит в основе ультразвуковой дефектоскопии.

При Р. з. на случайных поверхностях или объёмных неоднородностях образуется т. н. пятнистая интерференц. структура (спекл-структура; см. *Спекл-интерференметрия*). На основе её анализа разработаны эфф. дистанц. методы определения разл. параметров природных неровностей и неоднородностей; развиты акустич. методы разведки полезных ископаемых, в частности железомарганцевых конкреций на дне океана, созданы навигат. приборы — корреляц. лаги для измерения абс. скорости движения судна относительно дна океана, а также устройства для определения с высокой точностью смещения судна относительно фиксир. точки.

При Р. з. на периодических неровных или периодически неоднородных поверхностях рассеянное поле состоит из суперпозиции плоских волн (дифракц. спектр разл. направлений), распространяющихся в дискретных направлениях, определяемых условием Брэгга. Если период неровностей (неоднородности) меньше половины длины звуковой волны, то амплитуды всех рассеянных волн (помимо зеркально отражённой волны) экспоненциально убывают при удалении от поверхности и рассеянное поле сосредоточено вблизи поверхности (ближнее поле).

Лит.: Ливиняу Л. Д., Лифшиц Е. М., Гидродинамика, 4 изд. М., 1988; Исакович М. А., Общ. акустика, М., 1973; Чернов Л. А., Волны в случайно-неоднородных средах, М., 1975; Киттель Ч., Введение в физику твёрдого

тела, пер. с англ., М., 1978; Исмаири А., Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, пер. с англ., т. 1—2, М., 1981; Бреховский Л. М., Диксон В. Ю. П., Теоретические основы акустики океана, П., 1982; Ю. П. Диксон, **РАССЕЯНИЕ МИКРОЧАСТИЦ** — процесс столкновения частиц, в результате к-рого либо меняются их импульсы (у упругого рассеяния), или наряду с изменением импульсов меняются также внутри. состояния частиц, либо образуются др. частицы (в е у р у гие процессы). Одна из осн. количественных характеристик как упругого рассеяния, так и неупругих процессов — аффективное сечение ие процесса — величина, пропорциональная вероятности процесса. Измерение сечений процессов позволяет изучать законы взаимодействия частиц, исследовать их структуру.

Классическая теория рассеяния. Согласно законам классич. нерелятивистской механики, задачу рассеяния двух частиц массами m_1 и m_2 можно свести путем перехода к системе центра инерции (с. ц. и.) сталкивающихся частиц к задаче рассеяния одной частицы с приведенной массой $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ на неподвижном силовом центре. Траектория частицы, проходящей через силовое поле (с центром O), искривляется — происходит рассеяние. Угол θ между начальными ($P_{нач}$) и конечными ($P_{кон}$) импульсами рассеиваемой частицы наз. углом рассеяния θ . Угол рассеяния зависит от взаимодействия между частицами в от прицельного параметра p — расстояния, на к-ром частица пролетала бы от силового центра, если бы взаимодействие отсутствовало (рис. 1).

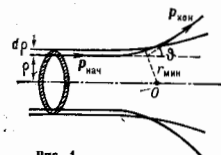


Рис. 1.

то $dN = 2\pi p dr$, а сечение упругого рассеяния $d\sigma$ определяется как отношение dN/n и равно

$$d\sigma = dN/n = 2\pi p dr. \quad (1)$$

Полное сечение рассеяния σ получается интегрированием (1) по всем прицельным параметрам. Если a — мин. прицельный параметр, при к-ром частица не рассеивается, то $\sigma = \pi a^2$.

Квантовая теория рассеяния. В квантовой теории упругое рассеяние и неупругие процессы описываются матричными элементами S -матрицы, или матрицы рассеяния (амплитудами процессов), — комплексными величинами, квадраты модуля к-рых пропорц. сечениям соответствующих процессов. Через матричные элементы S -матрицы выражаются физ. величины, непосредственно измераемые на опыте: сечение, поляризация частиц, асимметрия, компоненты тензора корреляции поляризаций и т. д. С др. стороны, эти матричные элементы могут быть вычислены при определ. предположений о виде взаимодействия. Сравнение результатов опыта с теоретич. предсказаниями позволяет получить информацию о взаимодействии.

Общие принципы инвариантности (инвариантность относительно вращений, пространственной инверсии, обращения времени и др.) существенно ограничивают возможный вид матричных элементов процессов и позволяют получить проверяемые на опыте соотношения. Напр., из инвариантности относительно вращений и пространственной инверсии, к-рым отвечают законы сохранения углового (орбитального) момента и четности, следует, что поляризация конечной частицы, возникающая при рассеянии неполяризов. частиц, направлена по нормали к плоскости рассеяния (плоскости, про-

ходящей через начальный и конечный импульсы частицы). Т. о., измеряя направление вектора поляризации, можно выяснить, сохраняется ли четность во взаимодействии, обуславливающем процесс. *Изотопическая инвариантность* сильного взаимодействия приводит к соотношениям между сечениями реал. процессов, а также к запрету нек-рых процессов. Напр., при столкновении двух дейтронов не могут образоваться α -частица и ${}^3\text{He}$ -мезон. Эксперим. исследование этого процесса подтвердило справедливость изотопич. инвариантности.

Условие унитарности S -матрицы, являющееся следствием сохранения полной вероятности, также накладывает ограничения на матричные элементы процессов. Так, из этого условия вытекает *оптическая теорема*.

Из общих принципов квантовой теории (микрорепрезентации условия, *реалистической инвариантности* и др.) следует, что элементы S -матрицы являются *аналитическими функциями* в нек-рых областях комплексных переменных. Аналитичность S -матрицы позволяет получить ряд соотношений между определяемыми на опыте величинами — дисперсионные соотношения (см. *Дисперсионный соотношений метод*), *Померанчука теорему* и др.

В случае упругого рассеяния бесспиновых частиц решение *Шрёдингера уравнения* для волновой ф-ции $\psi(r)$ при $r \rightarrow \infty$ имеет вид

$$\psi(r)_{r \rightarrow \infty} \sim \exp(ikr) + f(\theta) r^{-1} \exp(ikr). \quad (2)$$

Здесь r — расстояние между частицами, $k = p/\hbar$ — волновой вектор, p — импульс в с. ц. и. сталкивающихся частиц, θ — угол рассеяния, $f(\theta)$ — амплитуда рассеяния, зависящая от угла рассеяния и энергии сталкивающихся частиц. Первый член в этом выражении описывает падающие частицы, второй — рассеянные. Дифференц. сечение рассеяния определяется как отношение числа частиц, рассеянных за единицу времени в элемент телесного угла $d\Omega$, к плотности потока падающих частиц. Сечение рассеяния на угол θ (в с. ц. и.) в единичный телесный угол равно

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2. \quad (3)$$

Амплитуду рассеяния обычно разлагают в ряд по начальным волнам — состояниям с определенным орбитальным моментом l :

$$f(\theta) = \frac{i}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)(S_l - 1) P_l(\cos\theta). \quad (4)$$

Здесь $P_l(\cos\theta)$ — полином Лежандра, S_l — комплексные ф-ции энергии, зависящие от характера взаимодействия и являющиеся элементами S -матрицы (в представлении, в к-ром диагональна энергия, угл. момент и его проекция). Если число падающих на центр частиц с орбитальным моментом l равно числу идущих от центра частиц с тем же моментом (упругое рассеяние), то $|S_l| = 1$. В общем случае $|S_l| \leq 1$. Эти условия — следствие условия унитарности S -матрицы. Если возможно только упругое рассеяние, то $S_l = \exp(2i\delta_l)$ и рассеяние в состоянии с данным l характеризуется только одним вещественным параметром δ_l — фазой рассеяния. Если $\delta_l = 0$ при нек-ром l , то рассеяние в состоянии с орбитальным моментом l отсутствует.

Полное сечение упругого рассеяния равно

$$\sigma_{\text{уп}} = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l^{\text{уп}}, \quad (5)$$

$$\sigma_l^{\text{уп}} = \pi \lambda^2 (2l+1) |S_l - 1|^2, \quad (6)$$

где $\sigma_l^{\text{уп}}$ — частичное сечение упругого рассеяния частиц с орбитальным моментом l , $\lambda = 1/k$ — длина

волны де Бройля частицы. При $S_l = -1$ сечение $\sigma_l^{\text{упр}}$ достигает максимума и равно

$$\left(\sigma_l^{\text{упр}}\right)_{\text{макс}} = 4\pi\lambda^2(2l+1), \quad (7)$$

при этом $\delta_l = \pi/2$ (резонанс в рассеянии). Т. о., при резонансе сечение процесса определяется де-бройлевской длиной волны λ и для медленных частиц, для к-рых $\lambda \gg R_0$, где R_0 — радиус действия сил, намного превосходит величину λR_0^2 (классич. сечение рассеяния). Это явление (необъяснимое с точки зрения классич. теории рассеяния) обусловлено волновой природой микрочастиц.

Др. проявлением волновой природы микрочастиц служит дифракц. рассеяние — упругое рассеяние быстрых частиц на малые углы $\theta \sim \lambda/R_0$ (при $\lambda \ll R_0$), обусловленное отклонением де-бройлевских волн падающих частиц в область геом. тени, возникающей за рассеивающей частицей (см. рис. 1 в ст. Дифракционное рассеяние). Т. о., дифракц. рассеяние аналогично явлению дифракции света.

Зависимость сечения рассеяния от энергии вблизи резонанса определяется Брейта — Вигнера формулой

$$\sigma_l = 4\pi\lambda^2(2l+1) \frac{(\Gamma/2)^2}{(\epsilon - \epsilon_0 + \Gamma/2)^2}, \quad (8)$$

где ϵ_0 — энергия, при к-рой сечение достигает максимума (положение резонанса), а Γ — ширина резонанса. При $\epsilon = \epsilon_0 + \Gamma/2$ сечение $\sigma_l = \sigma_l^{\text{макс}}/2$.

Полное сечение всех неупругих процессов

$$\sigma_{\text{неупр}} = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l^{\text{неупр}}, \quad (9)$$

$$\sigma_l^{\text{неупр}} = \pi\lambda^2(2l+1)(1-|S_l|^2). \quad (10)$$

Условие унитарности ограничивает величину парциального сечения для неупругих процессов:

$$\sigma_l^{\text{неупр}} \leq \pi\lambda^2(2l+1). \quad (11)$$

Для короткодействующих потенциалов взаимодействия осн. роль играют фазы рассеяния $l \lesssim R_0/\lambda$, где R_0 — радиус действия сил; величина λ определяет мин. расстояние, на к-рое может приближаться к центру сил свободная частица с моментом l (прицельный параметр в квантовой теории). При $R_0/\lambda \ll 1$ (малые энергии) следует учитывать только парциальную волну с $l=0$ (S-волну). Амплитуда рассеяния в этом случае

$$f \approx \frac{1}{2ik} [\exp(2i\delta_0) - 1] = \frac{1}{k \text{ctg} \delta_0 - ik} \quad (12)$$

и сечение рассеяния не зависит от θ (рассеяние сферически симметрично). При малых энергиях

$$k \text{ctg} \delta_0 \approx -\frac{1}{a} + \frac{1}{r_0} k^2. \quad (13)$$

Параметры a и r_0 наз. соответственно длиной рассеяния и эффективным радиусом рассеяния. Их находят из опыта, и они являются важными характеристиками сил, действующих между частицами. Длина рассеяния равна по величине и противоположна по знаку амплитуде рассеяния при $k=0$. Полное сечение рассеяния при $k=0$ равно $\sigma_0 = 4\pi a^2$.

Если у частиц имеется связанное состояние с малой энергией связи, то их рассеяние при $R_0/\lambda \ll 1$ носит резонансный характер. Типичный пример — рассеяние нейтронов протонами в состоянии с полным спином $J=1$, в к-ром система нейтрон — протон имеет связанное состояние (дейтрон). В этом случае длина

рассеяния a отрицательна, а сечение рассеяния зависит только от энергии связи.

Если параметр R_0/λ невелик, фазы рассеяния могут быть получены из измеренных на опыте сечений, поляризации и др. величин. Эта процедура наз. *фазовым анализом*. Найденные фазы рассеяния сравниваются с теоретич. предсказаниями и позволяют получить важную информацию о характере взаимодействия.

Информацию о взаимодействиях дают измерения поляризационных эффектов. Для упругого рассеяния частиц со спином 0 на частицах со спином $1/2$ (напр., пион-нуклонного рассеяния) вместо (2) имеем

$$\Psi_0(r) \approx \exp(ikr)u_0 + M_{00'}(k', k)u_0' \exp(ikr)/r. \quad (14)$$

Здесь $k = p/|p|$ и $k' = p'/|p'|$ (p и p' — начальный и конечный импульсы в с. ц. н.), u_0 — спинор, описывающий состояние нач. частиц, $M_{00'}(k', k) - 2 \times 2$ матрица, называемая спиновой матрицей рассеяния и, σ' — спиновый индекс (по повторяющемуся индексу σ' производится суммирование). Из сохранения полного момента и четности (инвариантности относительно вращений и пространственных отражений) следует, что матрица M имеет общий вид

$$M = a + b\sigma_n,$$

где a и b — комплексные функции скаляров kk' и k^2 , σ_n — Паули матрица, $\mathbf{n} = [kk']/[kk']$ — единичный вектор нормали к плоскости рассеяния.

Примем за ось квантования вектор \mathbf{n} . Из (14) следует, что амплитуда рассеяния частиц со спином, направл. «вверх», отличается от амплитуды рассеяния частиц со спином, направл. «вниз». Если, напр., начальные (рассеиваемые) частицы неполяризованные (ср. значение спина равно нулю), то после рассеяния абс. величина ср. значения спина (поляризация) равна $2\text{Re}(ab^*)/(|a|^2 + |b|^2)$.

В общем случае спиновое состояние частиц описывается спиновой матрицей плотности. Для частиц со спином $1/2$ она имеет вид

$$\rho_0 = \frac{1}{2}(1 + \sigma P_0), \quad (15)$$

где $P_0 = \langle \sigma \rangle$ — вектор поляризации нач. частиц (ср. значение спина). Спиновая матрица плотности ρ рассеянных частиц связана со спиновой матрицей плотности нач. частиц ρ_0 соотношением

$$\rho = M \rho_0 M^* \quad (16)$$

(* означает эрмитово сопряжение). В случае поляризов. нач. частиц сечение рассеяния равно

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{P_0} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_0 (1 + A P_0), \quad (17)$$

где $(d\sigma/d\Omega)_0$ — сечение рассеяния неполяризов. частиц. Вектор A наз. вектором асимметрии. Если сохраняются полный угл. момент и четность, то

$$A = A_n, \quad (18)$$

где асимметрия A является ф-цией kk' и k^2 . Для того чтобы определить A из данных опыта, следует измерить сечение при разных значениях нач. поляризации. Имейм

$$\frac{(d\sigma/d\Omega)_{P_0} - (d\sigma/d\Omega)_{-P_0}}{(d\sigma/d\Omega)_{P_0} + (d\sigma/d\Omega)_{-P_0}} = P_0 A = (P_0 n) A. \quad (19)$$

Соотношение (19) имеет место для упругого рассеяния поляризов. частиц со спином $1/2$ на неполяризов. частицах с произвольным спином s . При этом справедливо след. равенство:

$$A = P, \quad (20)$$

где P — поляризация, возникающая при рассеянии неполяризов. частиц. Равенство поляризация — асим-

метрия является точным, основанным только на принципах инвариантности относительно вращений, пространственных отражений (*пространственной инверсии*) и обращения времени (в случае $\lambda = 0$ оно следует только из инвариантности относительно вращений и отражений). Равенство (20) широко используется в физике: оно лежит в основе измерения поляризации эффектов в рассеянии адронов при высоких энергиях (см. *Поляризация эффекты*).

В качестве примера приведём схему опыта по двойному рассеянию, в котором определяется поляризация. Рассмотрим упругое рассеяние на угол θ неполяризованной частицы со спином $1/2$ на неполяризованной мишени с произвольным спином s . После рассеяния частицы в общем случае окажутся поляризованными. Из инвариантности относительно вращений и отражений следует, что поляризация P рассеянных частиц со спином $1/2$ равна $P = P_n$, где n_1 — единичный вектор нормали к плоскости рассеяния, а P является ф-цией энергии и угла рассеяния. Пусть теперь рассеянные частицы со спином $1/2$ повторно рассеиваются на угол θ в той же плоскости и на такой же мишени (рис. 2). При рассеянии налево ($n_2 = n_1$, где n_2 — единичный вектор нормали во втором рассеянии) сечение равно

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_L = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_0 (1 + P^2). \quad (21)$$

При рассеянии в той же плоскости на угол θ направо ($n_2 = -n_1$) имеем

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_R = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_0 (1 - P^2). \quad (22)$$

Т. о., левоправая асимметрия во втором рассеянии равна

$$A_{LR} = \frac{(d\sigma/d\Omega)_L - (d\sigma/d\Omega)_R}{(d\sigma/d\Omega)_L + (d\sigma/d\Omega)_R} = P^2. \quad (23)$$

Измерение асимметрии A_{LR} позволяет, следовательно, определить поляризацию, возникающую при рассеянии неполяризованных частиц.

Один из осн. приближенных методов теории рассеяния — *волуционная теория*. Если падающая плоская волна, описывающая нач. частицы, слабо возмущается потенциалом взаимодействия, то применимо т. н. *борновское приближение* (первый член ряда теории возмущений). Амплитуда упругого рассеяния в борновском приближении равна

$$f(\theta) = -2\mu \int_0^\infty V(r) \frac{\sin(qr)}{qr} r^2 dr, \quad (24)$$

где $q = 2k \sin(\theta/2)$, $V(r)$ — потенциал взаимодействия.

Для описания процессов рассеяния при высоких энергиях используются методы квантовой теории поля, в частности метод *Фейнмана диаграмм*. Напр., упругое рассеяние электронов протонами в низшем порядке теории возмущений обусловлено обменом фотоном между электроном и протоном (рис. 3). В выражение для сечения этого процесса входят заряды e и магн. ф-м-факторы протона — величин, характеризующие распределение электрич. заряда и магн. момента протона. Информация о них может

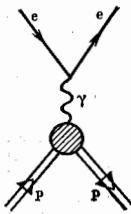


Рис. 3.

быть получена непосредственно из эксперим. значений сечения упругого рассеяния электронов протонами. При достаточном высоких энергиях наряду с упругим $e-p$ рассеянием становятся возможными неупругие процессы образования адронов. Если на опыте регистрируются только рассеянные электроны, то тем самым измеряется сумма сечений всех возможных процессов $e^+p \rightarrow e^+X$ (инклюзивное сечение *глубоко неупругого процесса* рассеяния), где X — любая возможная совокупность образующихся в реакции адронов. Эти опыты позволили получить важную информацию о структуре нуклона. Особое значение для исследования структуры адронов имеют *инклюзивные процессы* при адрон-адронных столкновениях высокой энергии.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; Ситенко А. Г., Лекции по теории рассеяния, К., 1971.

РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ — взаимодействие нейтронов с веществом. Особенности нейтронов определяют характер этого взаимодействия. Нейтрон электрически нейтрален и потому легко проникает в глубь атома и взаимодействует с ядром или с отд. нуклонами за счёт ядерных сил, быстро спадающих с расстоянием. При упругом рассеянии суммарная кинетич. энергия нейтрона и ядра сохраняется. Такое $R. v. н. в. п. о. т. н. п. c. a. l. y. m. y.$ и характеризуется амплитудой потенц. рассеяния. Если ядро захватывает нейтрон и образуется *составное ядро*, то рассеяние наз. *резонансным*, а соответствующая амплитуда — амплитудой резонансного рассеяния (см. *Нейтронная спектроскопия*). Интерференция процессов потенциального и резонансного рассеяний приводит к тому, что суммарная амплитуда рассеяния для ядер, поглощающих нейтроны, может быть комплексной величиной (см. *Рассеяние микрочастиц*).

$R. v. н.$ играет важную роль в исследовании конденсиров. сред. Длина волны де Бройля для тепловых нейтронов (см. *Нейтронная физика*) при обычных темп-рах порядка 0,1 нм, т. е. совпадает с межатомами расстояниями в кристаллах и молекулах. Поэтому *дифракция нейтронов*, упруго рассеянных на кристаллич. решётке, позволяет исследовать атомную структуру кристаллов (см. *Нейтроннография структурная*).

Нейтрон обладает дипольным магн. моментом, к-рый вызывает рассеяние на атомарных электронах. Появление дополнит. дифракц. максимумов у кристаллов при понижении темп-ры ниже точки Кюри позволяет исследовать магн. структуру и динамику кристаллов — распределение спиновой плотности, магнитный спектр (см. *Магнитная нейтроннография*).

Энергии тепловых нейтронов близка к энергии тепловых колебаний атомов (*фононов*). Фононы могут обмениваться энергией с нейтронами, что даёт возможность исследовать колеб. моды в твёрдом теле — *фононовый спектр* (см. *Неупругое рассеяние нейтронов*).

РАССЕЯНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА в кристаллич. твёрдых телах — процесс взаимодействия электрона проводимости (дырки) с нарушенными идеальной периодичности кристалла, сопровождающийся переходом электрона из состояния с импульсом p в состояние с импульсом p' . Рассеяние на зап. упругим, если энергии электрона в начальном и конечном состояниях равны, $\mathcal{E}(p) = \mathcal{E}(p')$, или неупругим, если $\mathcal{E}(p) \neq \mathcal{E}(p')$. Источником упругого рассеяния являются статич. дефекты — примесные атомы, дислокации, границы кристаллич. зёрен и т. п. (см. *Дефекты в кристаллах*). Осн. источником неупругого рассеяния являются *колебания кристаллической решётки*. Рассеяние электрона на колебаниях решётки обусловлено в терминах испускания и поглощения *фононов* движущимся электроном. В нек-рых случаях существует неупругое рассеяние на др. *мезочастицах* — магнтонах, плазмонах. Особое положение занимает $R. v. н. в. д. р. u. g.$ на другие (см. *Мезоэлектронное рассеяние*).

Р. н. з. является причиной того, что любое неравновесное по энергии или импульсу распределение электронов, созданное внеш. возмущением (электрич. поле, свет), с течением времени релаксирует к равновесному фермиевскому распределению $f_F(\mathcal{E})$, соответствующему темп-ре кристалла T . В процессе релаксации упругое рассеяние «размешивает» распределение равномерно в пределах каждой изоэнергетич. поверхности $\mathcal{E}(p) = \text{const}$, а неупругое — устанавливает равновесное распределение $f_F(\mathcal{E})$ между изоэнергетич. поверхностями с разными \mathcal{E} . Время, необходимое для достижения равномерного распределения на изоэнергетич. поверхности, наз. временем релаксации импульса $\tau_p(\mathcal{E})$ или транспортным временем релаксации. Время, необходимое для установления равновесного распределения в области энергий порядка \mathcal{E} , наз. временем релаксации энергии $\tau_E(\mathcal{E})$. Если $\tau_E \gg \tau_p$, рассеяние наз. квазиупругим. В этом случае установление равновесия идет в 2 этапа: сначала быстро (за время τ_p) неравновесное распределение выравнивается на каждой изоэнергетич. поверхности и превращается в неравновесное распределение по энергиям, к-рое затем медленно (за время τ_E) релаксирует к равновесному распределению $f_F(\mathcal{E})$.

Возмущением, ответственным за Р. н. з., является разность между истинным потенциалом $V(r, t)$, действующим на электрон в реальном кристалле, и периодич. потенциалом $V_0(r, t)$, действующим в идеальном кристалле с неподвижными атомами (r — пространственная координата электрона). Возмущение $\delta V = V - V_0$ определяет вероятность рассеяния $W_{p \rightarrow p'}$. В вырожденных полупроводниках и металлах следует учитывать принцип Паули, так что фактич. вероятность перехода равна $W_{p \rightarrow p'} [1 - f(p')]$. Кроме того, при большой плотности носителей рассеяние ослабляется экранированием возмущения из-за перераспределения носителей в пространстве.

Рассеяние на фононах. Вероятность рассеяния электрона при испускании или поглощении фонона с импульсом q и энергией $\hbar\omega_q$ (без учета принципа Паули) определяется выражением

$$W_{p \rightarrow p'}^{\pm q} = -\frac{2\pi}{\hbar} M_{p \rightarrow p'}^{\pm q} \left| \delta(\mathcal{E}_p - \mathcal{E}_{p'} \mp \hbar\omega_q) \left(N_q + \frac{1}{2} \pm \right) \pm \frac{1}{2} \right|. \quad (1)$$

Здесь верх. и ниж. знаки соответствуют испусканию и поглощению фонона; числа фононов с импульсом q определяются распределением Планка (см. Планка закон излучения):

$$N_q = [\exp(\hbar\omega_q/kT) - 1]^{-1}. \quad (2)$$

Матричный элемент M перехода $p \rightarrow p'$ содержит закон сохранения импульса: $p - p' \mp q = b$ (b — произвольный вектор обратной решетки). Переходы, для к-рых $b = 0$, наз. нормальными; если $b \neq 0$, говорят о переходах с пересосом (см. Пересос процессы). Дельта-функция δ отражает закон сохранения энергии. Вероятность рассеяния с испусканием фонона W^+ пропорц. $N_q + 1$. Два слагаемых, соответствующие спонтанному и индуцированному рассеянию с поглощением фонона W^- пропорц. N_q , поэтому поглощение фонона всегда является индуцированным.

Рассеяние электрона на фононах в большой степени определяется законами сохранения энергии и импульса (кинематич. факторы), а также принципом Паули. Поэтому картина рассеяния различна для акустич. и оптич. фононов, имеющих разные законы дисперсии $\mathcal{E}(p)$, и зависит от степени вырождения электронного газа. Кинематика позволяет установить, какие фононы дают осн. вклад в рассеяние, какова степень упруго-

сти рассеяния, а также является ли оно индуцированным или спонтанным.

Рассеяние на акустических фононах в полупроводниках. Т. к. скорость электрона v имеет порядок скорости звука a только при очень малой его энергии ($\mathcal{E} \approx mv^2 \approx 0,1$ К), то в реальных условиях $v \gg a$. Это означает, что возмущение, создаваемое акустич. фононом, почти статично, а рассеяние электронов всегда квазиупруго. Из кинематики следует, что осн. вклад в рассеяние вносят фононы с импульсом $q \approx p$; поэтому направленный импульс электрона теряется всего за неск. столкновений. Энергия фонона с таким импульсом $\hbar\omega_q = \hbar a q \approx \hbar a p \approx (mv^2)^{1/2} \ll \mathcal{E}$, так что для релаксации энергии требуется много столкновений, т. е. действительно $\tau_E \gg \tau_p$.

Является ли рассеяние индуцированным или спонтанным, зависит от соотношения между энергией фонона $\hbar a p$ и тепловой энергией T . Эти величины сравниваются, когда энергия электрона равна $\mathcal{E} = T^2/mv^2$. Если $\mathcal{E} \gg T$, то характерны $N_q \ll 1$; доминирует спонтанное испускание фононов (динамич. трение), и движение электрона по осн энергиям \mathcal{E} есть систематич. дрейф вниз. При $\mathcal{E} \ll T$ доминируют индуциров. переходы, т. к. $N_q \gg 1$. При этом испускание происходит не намного чаще, чем поглощение, и движение электрона по осн энергиям превращается в диффузию.

Рассеяние на акустических фононах в металлах и вырожденных полупроводниках. Вследствие закона сохранения импульса наиб. вероятно взаимодействие с фононами, импульс к-рых $\approx p_F$, где p_F — импульс Ферми (см. Ферми-поверхность). Но испусканию таких фононов (с энергией $\hbar\omega_q \approx \hbar a p_F$) может препятствовать принцип Паули, если превышение энергии электрона \mathcal{E} над энергией Ферми \mathcal{E}_F много меньше $\hbar a p_F$, а поглощение может ослабляться из-за малого числа таких фононов, если $T \ll \hbar a p_F$. Поэтому характер рассеяния сильно зависит от T при превышении энергии электрона над энергией Ферми. При $T \gg \hbar a p_F$ почти для всех электронов $\mathcal{E} - \mathcal{E}_F \gg \hbar a p_F$ (указанные ограничения несущественны) и рассеяние (с испусканием и поглощением) идет на фононах с $q \approx p_F$ и энергией $\hbar\omega_q \approx \hbar a p_F$. Для релаксации импульса требуется неск. столкновений, а для релаксации энергии — много (квазиупругое рассеяние). При $T \ll \hbar a p_F$ поглощение фононов с энергией $\hbar\omega_q \approx \hbar a p_F$ маловероятно, но если $\mathcal{E} - \mathcal{E}_F \gg \hbar a p_F$, то принцип Паули не запрещает испускание таких фононов (в осн. спонтанное). Рассеяние, как и при высоких темп-рах, квазиупруго. Если же $\mathcal{E} - \mathcal{E}_F \ll \hbar a p_F$, то принцип Паули разрешает только испускание фононов с $q \ll p_F$. Такое рассеяние является малопроизвольным, и выравнивание распределения электронов на поверхности Ферми происходит диффузно. Для полной релаксации импульса требуется много столкновений, релаксации же энергии происходит за неск. столкновений (неупругое рассеяние).

Рассеяние на оптических фононах. При рассеянии в металлах существенны оптич. фононы во всей зоне Бриллюэна, в осн. коротковолновые с $q \approx b_0$, где b_0 — размер Бриллюэна зонн. В полупроводниках в рассеянии участвуют только оптич. ДВ-фононы с $q \ll b_0$. Частоту этих фононов ω_0 можно считать не зависящей от q . Рассеяние на оптич. фононах квазиупруго только при $\mathcal{E} \gg \hbar\omega_0 \approx 400$ К, т. е. только при очень высоких энергиях электронов (см. Горячие электроны). В области энергий $\mathcal{E} \leq \hbar\omega_0$ проявляются неупругий и пороговый характеры рассеяния. Это существенно при низких темп-рах $T \ll \hbar\omega_0$, когда ниже порога ($\mathcal{E} < \hbar\omega_0$) рассеяние слабое и возможно только за счет маловероятного поглощения фонона, пропорционального $N_0 = \exp(-\hbar\omega_0/kT) \ll 1$, а выше порога ($\mathcal{E} > \hbar\omega_0$) рассеяние сильное — оно происходит при спонтанном испускании фонона.

Деформационное и поляризацонное рассеяния. В выражение (1) входит матричный элемент M возмущения δV на блоховских ф-циях ψ (см. Блоховские электроны), обычно δV и ψ неизвестны, поэтому M можно найти только численными расчётами. Однако если рассеяние происходит на ДВ-фононах, эту трудность можно обойти. Для этого следует усреднить δV по объёму с размерами, большими постоянной решётки a_0 и меньшими длины волны фонона $\lambda = 2\pi/q$. В результате усреднения появляется элктрич. макрполе. Для δV , созданного акустич. фононом, $\varphi(r, t)$ (r — координата точки, в окрестности к-рой произведено усреднение) представляет собой элктрич. поле, сопровождающее волну деформации (пьезополе). В случае оптич. фонона $\varphi(r, t)$ — поле, возникающее из-за отст. смещения разнородно заряженных подрешёток (см. Динамика кристаллической решётки). Рассеяние, обусловленное элктрич. макрполем, наз. п о л я р и з а ц и о н н ы м. Матричные элементы M для рассеяния, обусловленного макрполем, можно вычислять, представляя волновые ф-ции электрона в виде плоских волн.

Др. источником рассеяния является микрополе $\delta V = \delta V - e\varphi$, вышавшее при усреднении. В области усреднения, где $e\varphi$ почти постоянно, δV — почти периодич. ф-ция q . В этой области электрон движется в периодич. поле $V_0 + \delta V$ и его закон дисперсии $\mathcal{E}(\mathbf{p})$ отличается от закона дисперсии $\mathcal{E}(\mathbf{p})$ в идеальной решётке. В др. области усреднения будут другие δV и другие $\mathcal{E}(\mathbf{p})$. Т. к. частоты фононов меньше электронных, то закон дисперсии $\mathcal{E}(\mathbf{p})$ «следит» за колебаниями решётки, т. о., в кристалле, в к-ром возбуждены ДВ-фононы, закон дисперсии медленно меняется в пространстве и времени; он описывается ф-цией $\mathcal{E}(\mathbf{p}; r, t)$, характерные масштабы изменения к-рой такие же, как у $\varphi(r, t)$. Двигаясь в среде с перем. законом дисперсии, электрон рассеивается (как свет в мутной среде), даже если макрполе отсутствует. Такое рассеяние наз. д е ф о р м а ц и о н н ы м.

Матричные элементы M деформаци. рассеяния тоже можно вычислять, заменяя блоховские ф-ции на плоские волны, если в качестве возмущения брать не δV , а т. н. деформаци. потенциал $w(r, t)$. В полупроводнике с невырожденной зоной $w(r, t)$ имеет смысл сдвига для или потолка зоны в точке r в момент t , т. е. $w(r, t) = -\mathcal{E}(\mathbf{p}; r, t) - \mathcal{E}(\mathbf{p}_0)$, где \mathbf{p}_0 соответствует экстремуму зоны (или центру долины; в многодолинном полупроводнике деформаци. потенциал различен для электронов разных долин). В металле $w(r, t)$ — сдвиг поверхности Ферми, так что w зависит дополнительно от положения r на поверхности Ферми.

Матричные элементы в случае поляризацонного \bar{M} и деформационного \bar{M} рассеяний, вычисленные через $e\varphi$ и w , всегда сдвинуты по фазе на $\pi/2$. Это означает, что поляризац. и деформаци. рассеяния, обусловленные одной и той же фононовой модой, не интерферируют. Поэтому говорят о четырёх механизмах рассеяния: DA , DO , PA , PO , где первая буква указывает на характер рассеяния (деформационный или поляризацонный), вторая — на ветвь фононов (акустическая или оптическая).

Для вычисления \bar{M} и \bar{M} необходимо выразить $e\varphi$ и w через смещения атомов решётки. Связь φ со смещениями атомов находят из Пуассона уравнения $\nabla^2 \varphi = 4\pi \text{div} \mathbf{P}$, где \mathbf{P} — дипольный момент единицы объёма, возникающий при однородной статич. деформации решётки из-за смещения ядер и связанного с этим смещения электронов. Для деформации, созданной акустич. фононами $P_j = P_{jk} u_k$; где u_k — тензор деформации, а P_{jk} выражаются через пьезомодули. При деформации, созданной оптич. фононами $P_j = \gamma_{jk} \xi_k$, где ξ — вектор отст. смещения подрешёток, а γ_{jk} выражаются через статич. и динамич. диэлектрич. проницаемости (см. ниже).

Число независимых констант β и γ определяется симметрией кристалла. Так, в кубич. кристаллах с центром инверсии $\beta_{jkl} = \gamma_{jkl} = 0$, так что поляризац. рассеяние невозможно. В кубич. кристалле с двумя атомами в элементарной ячейке (большинство полупроводников) возможно поляризац. рассеяние для акустич. и оптич. фононов.

Деформаци. потенциал $w(r, t)$ определяется смещениями атомов в точке r в момент t . Для акустич. фононов $w = \sum_{ij} u_{ij}$, для оптич. фононов $w = \sum_i \xi_i$. Здесь ξ , Γ — т. н. константы деформаци. потенциала. Их число, кроме симметрии кристалла, зависит ещё от положения \mathbf{p}_0 в полупроводниках или на поверхности Ферми в металлах. В кубич. полупроводнике с $\mathbf{p}_0 = 0$ на симметрии следует, что $\sum_{ij} u_{ij} = \sum_i \xi_i = 0$. Это значит, что $w = \sum_i u_i$, где $u_i = u_{11} + u_{22} + u_{33}$ — отст. изменение объёма при деформации. Т. к. для поперечных акустич. фононов $u = 0$, то DA -рассеяние разрешено только для продольных фононов, DO -рассеяние запрещено для обеих ветвей. Если \mathbf{p}_0 лежит не в центре зоны Бриллюэна, то возможны DA - и DO -рассеяния на поперечных акустич. фононах.

Время релаксации τ_p и τ_E можно найти, если вычислить, с какой скоростью электрон с импульсом \mathbf{p} теряет энергию и направленный импульс при рассеянии, переходя во все др. состояния с импульсами \mathbf{p}' (скорость релаксации). В изотропном случае

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{\mathbf{p}}{\tau_p}; \quad \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}^*}{\tau_E},$$

где величина \mathcal{E}^* имеет порядок тепловой энергии T , если электронный газ невырожден, и равно ферми-энергии \mathcal{E}_F , если газ сильно вырожден (здесь и ниже $k = 1$).

Для акустич. фононов в полупроводниках при индущир. рассеянии ($\mathcal{E} \ll \mathcal{E}_F$) скорость релаксации импульса пропорц. T :

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{\tau} \frac{\pi}{\omega} \left(\frac{\rho}{\hbar \omega} \right) \pm 1/2. \quad (3)$$

Здесь T и \mathcal{E} выражены в долях энергии фонона; верх. знак относится к DA -рассеянию, нижний — к PA -рассеянию; τ — характерное время, определяемое соотношениями

$$\tau_{DA} = 2\pi \hbar \rho^2 / \Sigma^2 p_0^3; \quad \tau_{PA} = 2\pi \hbar \rho^2 / (\epsilon \mathcal{E})^2 p_0.$$

где ρ — плотность кристалла, p_0 — импульс электрона с энергией $\hbar \omega$. Типичные значения $\tau \approx 1-10$ пс.

При $\mathcal{E} \gg \mathcal{E}_F$ (спонтанное рассеяние) скорость релаксации импульса, т. е. τ_p , от T не зависит:

$$\left(\frac{1}{\tau_p} \right)_{DA} = \frac{1}{\tau_{DA}} \frac{4}{3} \delta_0^{1/2} \frac{\mathcal{E}}{\hbar \omega}; \quad \left(\frac{1}{\tau_p} \right)_{PA} = \frac{1}{\tau_{PA}} \frac{2}{3} \delta_0^{1/2}. \quad (4)$$

Здесь $\delta_0 = 2m^2 s^2 / \hbar \omega$ ($\sim 10^{-4} - 10^{-3}$) — степень упругости рассеяния, m — афф. масса электрона.

Время релаксации энергии τ_E не зависит от соотношения \mathcal{E} и \mathcal{E}_F :

$$\frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}^*}{\tau_E} = \frac{1}{\tau} \delta_0 \left(\frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}^*}{\hbar \omega} \right) \pm 1/2; \quad \mathcal{E}_{DA}^* = 2T; \quad \mathcal{E}_{PA}^* = T. \quad (4a)$$

Для акустич. фононов в металлах и вырожденных полупроводниках при высоких темп-рах ($T > \hbar s p_F$) τ_p определяется ф-той

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{\tau_p} \frac{T}{\hbar s p_F}; \quad \tau_E = \frac{\pi \hbar}{m p_F^2} \approx 0,01 \text{ пс.} \quad (5)$$

Скорость релаксации энергии

$$\frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}^*}{\tau_E} = \frac{\hbar s p_F}{\tau} \text{th} \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}^*}{T}. \quad (6)$$

При низких темп-рах ($T \ll \hbar \nu_{\text{сп}}$) и $\delta - \delta_F \gg \hbar \nu_{\text{сп}}$:

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{4}{5} \frac{1}{\tau_F} \left(\frac{\delta - \delta_F}{\hbar \nu_{\text{сп}}} \right)^2, \quad (7)$$

а для $\delta - \delta_F \ll \hbar \nu_{\text{сп}}$:

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{4}{5} \frac{1}{\tau_F} \left(\frac{\delta - \delta_F}{2 \hbar \nu_{\text{сп}}} \right)^3; \quad \frac{\delta - \delta_F}{\tau_p} = \frac{1}{2} \frac{\delta - \delta_F}{\tau_F} \left(\frac{\delta - \delta_F}{2 \hbar \nu_{\text{сп}}} \right)^3. \quad (8)$$

При рассеянии на оптич. фононах в полупроводниках в области квазиупругого рассеяния ($\delta \gg \hbar \omega$):

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{\tau} (2N_0 + 1) \left(\frac{\delta}{\hbar \omega} \right)^{\pm 1/2}; \quad N_0 = [\exp(\hbar \omega / T) - 1]^{-1}. \quad (9)$$

Здесь верх. знак относится к DO -рассеянию, нижний — к PO -рассеянию: $\bar{v}(DO) = \hbar \nu_{\text{сп}} / m^2 \Gamma^2$, $\bar{v}(PO) = (c/v_0) \alpha \omega$ (типичные значения $\bar{v} = 0,1-1$ по); здесь \bar{v} — плотность приведенной массы релаксируемых зарядных подрешёток, $\alpha = e^2 / \hbar v_0$ — Фрелиховская константа связи, $v_0 = \hbar \nu_{\text{сп}} / m$, $\epsilon^{-1} = \epsilon_{\infty}^{-1} - \epsilon_0^{-1}$, где ϵ_{∞} и ϵ_0 — высокочастотная и статическая диэлектрические проницаемости решётки. Время релаксации энергии

$$\frac{1}{\tau_E} = \frac{1}{\tau} \left(\frac{\delta}{\hbar \omega} \right)^2; \quad \sigma(DO) = 1/2; \quad \sigma(PO) = 3/2. \quad (10)$$

Рассеяние на примесных атомах. При рассеянии на примесных атомах возмущение δV обусловлено электр. полем (если примесь заряжена) и деформацией решётки в окрестности примеси. Иногда нужно учитывать обменные силы и магн. момент примеси. В случае аарж. примесей (примесных ионов) в полупроводниках вклад в δV от деформации решётки несуществен. Т. к. в полупроводнике $p \ll b_0$, то изменение импульса электрона при упругом рассеянии мало, а это значит, что рассеяние на больших расстояниях ($r \gg a_0$) определяется сглаженным потенциалом $\delta V(r)$. Такой потенциал не зависит от микроструктуры примеси и имеет кулоновский вид:

$$\delta V = Ze^2 / er, \quad (11)$$

где Ze — заряд иона. Поэтому время релаксации импульса τ_p можно вычислить, пользуясь Резерфорда формулой для сечения рассеяния заряд. частиц. Согласно этой ф-ле, дифференц. сечение рассеяния электрона под углом θ в телесном угле $d\Omega$:

$$d\sigma(\theta) d\Omega = \frac{1}{4} R^2 \text{cosec}^4(\theta/2) d\Omega; \quad R = Ze^2 / 4\pi m v^2, \quad (12)$$

где v — скорость электрона. Для вычисления τ_p необходимо усреднить σ по всем θ . При интегрировании (12) по θ получаем расходящийся интеграл, т. е. бесконечно большое сечение рассеяния. В действительности сечение рассеяния на примесном ионе конечно, т. к. кулоновский характер поля δV на больших расстояниях от примеси искажается полем др. примесных ионов и экранирующим полем электронов. Если учитывать первый фактор и «обрезать» кулоновский потенциал на $1/r_0$ расстояния между примесными центрами, равного $N^{-1/3}$ (N — концентрация примесей), то это приводит к ф-ле

$$\frac{1}{\tau_p} = 4\pi F Z^2 (e^2 \hbar / N) N p^{-3}. \quad (13)$$

Здесь $e_F = m^2 / 2\hbar e$ — боровская энергия, $\Phi = \ln \Phi e / Ze^2 N^{1/3}$. Ф-ла (13) носит назв. Кочулла — Вайскова формулы.

Если учитывать также экранирование кулоновского поля примесного иона свободными носителями заряда, то обрешение потенциала осуществляется его умножением на $\exp(-r/\lambda)$, где λ — длина экранирования. При этом в ф-ле (13) $\Phi = \ln(1-x) - x^2/(1+x)^2$, где $x = 2p/\lambda$ (Брукса — Херинга формула).

Рассеяние на нейтральных примесях в полупроводниках обусловлено кулоновскими и обменными силами, действующими между рассеивающимся электроном и атомом примеси. Используя аналогию с рассеянием на атоме водорода, обычно пользуются т. н. ф-лой Эргинсона:

$$\frac{1}{\tau_p} = C (\delta_B / \hbar) N a_B^3, \quad \delta \ll \delta_B, \quad (14)$$

где $a_B = \hbar^2 e / m e^2$ — боровский радиус, $C = 20$.

В металлах возмущение δV сильно зависит от сочетания атомов примеси и матрицы, поэтому к-л. общие ф-лы для τ_p получить не удастся. Обычно сечение рассеяния $\sigma \approx \sigma_0^2$, однако оно сильно возрастает при резонансном рассеянии электронов на примесных атомах с незаполненными d - и f -оболочками, когда на примеси существуют виртуальные уровни энергии (см. Кондо эффект).

Экспериментальные методы. Сказанное выше относительно к рассеянию носителей внутри одной зоны (долины) с энергетич. спектром носителей, вырожденным только по ориентации спина. В более сложных ситуациях (вырожденные зоны, многодолинные полупроводники) трудно определить теоретически, какой механизм рассеяния доминирует в той или иной области темп-р и энергий носителей. Поэтому осн. источник сведений о механизме Р. и з. является эксперимент. Механизм рассеяния импульса обычно определяют по измерению подвижности носителей заряда $\mu = (e/\tau_p) \tau_p$ и по ширине линии циклотронного резонанса $\Delta \omega_c = 1/\tau_p$. Входящее сюда τ_p усреднено по энергии. Для невырожденного полупроводника усреднение сводится к замене δ на T . Поэтому, изучая температурные зависимости μ или $\Delta \omega_c$, можно отличить рассеяние на примесях, когда $\mu \propto T^{3/2}$, от рассеяния на акустич. фононах, когда $\mu \propto T^{-1/2}$ для деформационного или $\mu \propto T^{1/2}$ для ларгариационного рассеяния.

Механизм релаксации энергии раскрывается в экспериментах с горячими электронами по зависимости μ или $\Delta \omega_c$ от сильного электр. поля или по спектрам горячей люминесценции.

Лит.: Кочулла Э., Кинетические свойства полупроводников в сильных электрических полях, пер. с англ., М., 1970; Вир Г. Л., Пия и ус Г. Е., Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, М., 1972; Wiegand J. D., Mobility of holes in III-V Compounds, в кн.: Semiconductors and semimetals, v. 10, N. Y., 1975, p. 91; Гагмакер В. Ф., Лавинья И. В., Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках, М., 1984.

РАСSEЯНИЕ РАДИОВОЛН — образование вторичного излучения, источниками к-рого являются неоднородности вещества, возмущаемые полем первичной волны. Степень когерентности излучения таких вторичных источников определяется корреляц. связями поля неоднородностей среды. Интерференция вторичных волн вызывает образование сложной дифракц. картины распределения рассеянного поля, зависящей от структуры неоднородностей. Динамика и эволюция поля неоднородностей приводит к соответствующей изменчивости его дифракц. картины, к флуктуациям параметров волны. Для матем. описания рассеяния эл.-магн. волн на случайных неоднородностях в макроскопич. теории используются Максвелла уравнения, в к-рых диэлектрич. проницаемость среды $\epsilon(r, t)$ является случайной ф-цией координат и времени. Корреляц. ф-ции случайного поля флуктуаций $\Delta \epsilon(r, t)$ определяют угловой и частотный спектры рассеянного поля, колебания его интенсивности, амплитуды, фазы, поляризации. Так, при распространении плоской волны ср. интенсивность рассеянной в заданном направлении волны характеризу-

ется сечением рассеяния, к-рое определяется спектральной плотностью флуктуаций проницаемости

$$\sigma(\theta) = \frac{\omega^4 \pi}{2c^4} \Phi_s(k_1 - k_2) \sin^2 \chi.$$

Величина $\sigma(\theta)$ определяет интенсивность рассеяния единицей рассеивающего объёма в единичный телесный угол. k_1, k_2 — волновые векторы падающей и рассеянной волн, θ — угол между ними (угол рассеяния), ω — круговая частота волны, χ — угол между вектором электрич. поля в первичной волне и вектором k_2 . Спектральная плотность $\Phi_s(x)$ является фурье-преобразованием коррел. ф-ции флуктуации диэлектрич. проницаемости.

На практике Р. р. играет двойную роль. С одной стороны, оно приводит к ослаблению первичной волны, с другой — рассеянные в разл. направлениях волны вызывают увеличение поля в пунктах, куда оно не проникает в отсутствие рассеяния вообще, и могут, т. о., быть использованы для радиосвязи. Напр., благодаря Р. р. на флуктуациях электронной плотности в ионосфере возможна авторизонная КВ-связь на расстояниях более 2000 км, что значительно превышает возможности чистой дифракц. проникновения поля за горизонт (см. *Загоризонтное распространение радиоволн*). Аналогично рассеяние волн на турбулентных неоднородностях тропосферы также способствует увеличению поля далеко за горизонтом. Явление Р. р. широко используется для целей дистанц. исследования свойств среды. Напр., Р. р. на тепловых флуктуациях микростройной плотности позволяет измерить концентрацию электронов, ионную и электронную темп-ры в ионосферной и лаб. плазмах. Неоднородности тропосферы эффективно исследуются с помощью рассеяния назад импульсов радиолокаторов.

Если в среде возможно распространение неск. типов волн, то процесс рассеяния сопровождается трансформацией энергии волн одного типа в энергию волн др. типа. Так, ал-матг. волна в неоднородной плазме порождает рассеянные плазменные волны (и наоборот). Волна с одним типом поляризации порождает волну с др. типом поляризации. В нерегулярных волноводах вза-рассеяния происходит трансформация энергии одних мод в энергию других.

Термин «Р. р.» употребляется не только в случае взаимодействия волн с неоднородностями, распределенными по объёму. О рассеянии говорят при отражении радиоволн от шероховатых поверхностей (от возмущённой поверхности моря, от поверхности Земли и т. д.), при описании дифракции на др. объектах (от следа ракеты, самолёта, облака и т. п.). Р. р. на метеорологических следах используется для целей кратковрем. связи, работающей в течение жизни метеоролог. следа. Рассеяние на искусств. образованиях и структурах широко применяется в физике и технике. Примером может служить Р. р. на возмущениях, порождаемых в атмосфере мощным звуковым импульсом. Доплеровское смещение частоты рассеянного сигнала позволяет определить скорость звука и, следовательно, высотное распределение темп-ры. Аналогично рассеяние волн на квазипериодич. структурах, возникающих при воздействии на ионосферу мощных радиоволн, служит для определения параметров верх. атмосферы (см. *Распространение радиоволн*).

Лит.: Татарский В. И., *Распространение волн в турбулентной атмосфере*, М., 1967; Введение в статистическую оптику, ч. 2 — Рытов С. М., Краудов Ю. А., Татарский В. И., Случайные волн., 1978; Исмаилов А., *Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах*, пер. с англ., т. 1—2, М., 1981.

РАССЯЕНИЕ СВЁТА — рассеяние волн оптич. диапазона, заключающееся в изменении пространственного распределения, частоты, поляризации оптич. излучения при его взаимодействии с веществом. Часто Р. с. баа. только преобразование угл. распределения свето-

вого потока, обусловленное пространственными неоднородностями показателя преломления среды и воспринимаемое как её несобств. свечение, напр. при визуализации лучей света в пыли, отражение и преломление света на поверхности твёрд. и т. п. Р. с. может проявляться как поглощение в виде ослабления лучей — *экстинкция*. Если частота рассеянного света ω' равна частоте падающего ω , то Р. с. наз. упругим или *релевским*, в остальных случаях Р. с. — неупругим процесс с перераспределением энергии между излучением и рассеивающей частью и, следовательно, с изменением частоты. Если $\omega' < \omega$, то Р. с. наз. *стоксовым*, при $\omega' > \omega$ — *антистоксовым*. При упругом Р. с. сохраняются фазовые соотношения между падающей и рассеянной волнами (*когерентное рассеяние света*); при неупругом Р. с. происходит фазовый сбой рассеянной волны (*некогерентное Р. с.*).

Квантовая теория рассеяния света. Последоват. описание Р. с. возможно только квантовой теорией взаимодействия света с веществом (в *квантовой электродинамике*). В этой теории элементарный акт Р. с. трактуется как поглощение веществом падающего фотона с энергией $\hbar\omega$, импульсом $\hbar k$ и поляризац. μ , а затем спонтанное испускание рассеянного фотона с энергией $\hbar\omega'$, импульсом $\hbar k'$ и поляризац. μ' . Вместе с таким процессом идёт и другой, когда внезапно испускается фотон с характеристиками $\hbar\omega', \hbar k'$ и μ' (рассеянный), а затем поглощается падающий. Оба процесса наглядно изображаются соответствующими диаграммами Фейнмана (рис. 1), в к-рых квантовые состояния

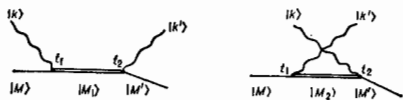


Рис. 1. Диаграммы Фейнмана для процесса однократного рассеяния света в веществе.

вещества и фотона до взаимодействия обозначены $|M\rangle$ и $|k\rangle = |\omega, k, \mu\rangle$, а после взаимодействия $|M'\rangle$ и $|k'\rangle = |\omega', k', \mu'\rangle$ соответственно. В промежуток между моментами поглощения t_1 и испускания t_2 вещество находится в состояниях $|M_1\rangle$ и $|M_2\rangle$, к-рые могут быть виртуальными или реальными и меплюющимися вза-взаимодействий в веществе и с излучением.

Если эти изменения велики, так что к моменту t_1 «забывается» состояние, сформированное в момент t_2 , т. е. рассеянный фотон статистически не связан с падающим, то такое Р. с. наз. *некогерентным*. Большие возмущения в промежуточных состояниях могут обусловить разного рода вторичные свечения, напр. *фотолуминесценцию*, к-рую традиционно не считают Р. с. Феноменология, особенности этого свечения — инерционность, задержка или затухание свечения (рассеяния), независимость спектра люминесценции от быстрых изменений характеристик падающего излучения.

В элементарном акте Р. с. закон сохранения энергии и импульса имеет вид

$$\hbar\omega + \mathcal{E}_M = \hbar\omega' + \mathcal{E}_M'; \quad \hbar k + p_M = \hbar k' + p_{M'}, \quad (1)$$

где $\mathcal{E}_M, \mathcal{E}_M'$ и p_M, p_{M}' — энергия и импульс атома (молекулы) в соответствующих M и M' состояниях.

Классическая теория рассеяния света. В рамках классической, волновой, теории света считается, что рассеянное излучение генерируется электрич. токами, вызываемыми в веществе падающим излучением. В классич. теории часто применяется дипольное приближение, в к-ром источником излучения считается электрич. диполь с моментом $p(t) = \text{Re} p_0 \exp(i\omega t)$. В этом при-

ближения интенсивности dI_n , вылучаемая диполем в направлении n в телесный угол $d\Omega_n$, даётся выражением

$$dI_n = \frac{a^2(pn)^2}{4\pi c^2} d\Omega_n, \quad (2)$$

где $n^2 = 1$ и c — скорость света в вакууме.

Гармонич. движение диполя вынуждается действием на заряды электр. поля с частотой ω , а значение p определяется либо у-рядами классич. механики с учётом $p = \sum e_j r_j$ (суммирование проводится по всем атомам с зарядами e_j и координатами r_j), либо квантовыми у-рядами при t , т. е. поупулюкласич. подходе, в к-ром полагают $p = \sum e_j \langle r_j \rangle$, где $\langle r_j \rangle$ — квантовое среднее координаты j -го локализ. заряда.

При феноменологич. описании считают $p = \hat{\alpha} E$, где $\hat{\alpha}$ — тензор *полярности* рассеивающей частицы, а E — напряжённость электр. поля действующего на неё излучения. Если заряды рассредоточены, рассеяное излучение получается в результате сложения парциальных полей, генерируемых элементарными дипольными моментами элементов объёма d^3r : $dp = P(r)d^3r$, где P — поляризация в точке r , определяемая тензором *диэлектрической проницаемости* $\hat{\epsilon}$ среды:

$$P(r) = (\hat{\epsilon} - 1)E(r)/4\pi. \quad (3)$$

Напряжённость поля $E(r)$, действующего в точке r , в общем случае отлагается от напряжённости поля падающего излучения. При суммировании вкладов элементарных диполей в ф-ле (2) следует учитывать интерференцию рассеянных волн, поэтому существенны фазы колебаний диполей и запаздывание прихода волн от них в место наблюдения.

Характеристики рассеяния света. Наиб. употребляемая количественная характеристика $P. c.$ на частицах — дифференциальное сечение рассеяния $d\sigma_k$, определяемое отношением рассеянного потока dI_n к плотности падающего потока $cE^2/4\pi$. В классич. и поупулюкласич. описании сечение определяется из (2), где p считается зависящим от E_0 линейно.

При квантовом подходе $P. c.$ описывается в *волнулюкласич. теории* как взаимодействие излучения с веществом и определяется ф-лой вероятности перехода в сплошном спектре состояний поля излучений в единицу времени. Сечение рассеяния определяется этой же ф-лой при условии, что поток падающего света считается равным одному фотону в единицу времени на единицу площади.

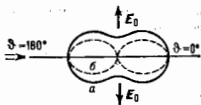
Сечение измеряется в единицах площади, и при упругом рассеянии полное сечение $\sigma_k = \int d\sigma_k$ (интегрирование по всем направлениям рассеяния) характеризуется с нек-рой долей условности, размер площади, «не пропускающей свет в направлении его падения. Сечение рассеяния может зависеть от поляризации, направления (аннизотропия $P. c.$), частоты падающего света (дисперсия $P. c.$).

Свето-рассеивающая способность сред характеризуют коэф. рассеяния R_n и дифференц. коэф. экстинкции dh_n . Первый показывает, какая доля светового потока, падающего на единицу поверхности среды, рассеивается единицей её объёма в заданном направлении.

Второй определяется как удельное (на единицу объёма V среды) дифференц. сечение рассеяния $dh_n = d\sigma_k k/V$. Обе величины измеряются в обратных длинах и связаны друг с другом соотношением, к-рое в случае изотропного рассеяния поупулюкласич. света имеет вид $h = (16\pi/3)R_{111}$, где h — полная экстинкция светорассеяния, R_{111} — коэф. рассеяния под углом 90° к направлению падения излучения.

Наглядное изображение $P. c.$ даёт *индикатриса* рассеяния (полярная диаграмма), показывающая распределение относит. интенсивности рассеянного света по направлениям (рис. 2). Вид индикатрисы зависит от частоты, поляризации и направления падающего излу-

Рис. 2. Индикатрисы дипольного рассеяния падающего света: неполяризованного (естественного) (а) и линейно поляризованного (б) света.



ния. Обычно используются индикатрисы для излучения, поляризованного в плоскости рассеяния, проходящей через волновые векторы k и k' падающего и рассеянного излучений, и поляризованного перпендикулярно этой плоскости.

Информация о связи поляризации и фаз падающей и рассеянной волн даёт матрица рассеяния. Применяются два типа матриц: одна связывает векторные величины — амплитуды падающей и рассеянной волн, другие связывают тензорные величины — *Стокса параметры* или элементы квантовых *матриц плотности* падающего и рассеянного полей. Первые матрицы применяются для описания когерентного рассеяния, вторые — при описании $P. c.$ частично когерентных световых потоков или потоков с меняющейся степенью когерентности. В случае изотропного $P. c.$ матрицы рассеяния зависят только от угла между k и k' — угла рассеяния θ .

Анизотропное $P. c.$ характеризуется количественной мерой — коэф. деполаризации, к-рый равен $\Delta = I_{\parallel}/I_{\perp}$ — отношению интенсивностей взаимно перпендикулярно поляризованных составляющих рассеянного первоначально неполяризованного падающего света (I_{\parallel} — составляющая рассеянного света, поляризованная вдоль направления падающего, а I_{\perp} — перпендикулярная к плоскости рассеяния).

Разнообразие и обилие факторов, определяющих характер $P. c.$, не позволяют единообразно и детально описать все случаи, поэтому условия идеализуют с равной степенью адекватности рассматриваемому случаю. Прежде всего различают $P. c.$ на отд. частицах и $P. c.$ в средах, т. е. для описания коллективной природы последнего необходимо использовать дополнит. статистич. методы. При этом бывает существенным учёт взаимодействий между отд. рассеивающими частицами.

Рассеяние света отдельными микрочастицами. $P. c.$ с вободным покоящимся электр. ном — процесс упругий с высокой точностью. Движущийся электрон рассеивает свет неуруго: замена частоты, определяемое (1), зависит от угла рассеяния и скорости v электрона, к-рая при $|v| \ll c$ полагается незначительной. В выражении для сдвига частоты

$$\omega - \omega' = v(k - k') \quad (4)$$

считается, что длины волновых векторов $|k| = |k'| = \omega/c$. Классич. теория объясняет эту передачу энергии и импульса при $P. c.$ *Доллера эффектом*. При $|v| \ll c$ $P. c.$ на электроне изотропное и без дисперсии (томпосонское рассеяние света), его сечение равно $\sigma_0 = (8\pi/3)r_0^2 = 6.65 \cdot 10^{-28} \text{ см}^2$, где $r_0 = e^2/mc^2$ — классич. радиус электрона. Индикатриса рассеяния (рис. 2) вверд такая же, как и назад, но различная для падающего излучения, поляризованного по-разному. При любой поляризации падающего излучения рассеянное под углом 90° излучение всегда линейно поляризовано ($\Delta = 0$).

$P. c.$ свободными или слабо связанными электронами (*Комптона эффект*) играет большую роль в астрофиз. плазме: оно определяет лучистое давление и процесс переноса в космич. объектах. $P. c.$ электронами металлов объясняет высокую отражат. способность поверхности металлов.

$P. c.$ отдельным атомом (связанным электронами) отличается сильной дисперсией рассеяния. В классич. теории дисперсия объясняется зависимостью амплитуды вынужденных колебаний атомного осциллятора от частоты падающего излучения. Свя-

важная с этим поляризуемость атомного осциллятора

$$\alpha = e^2 f / m (\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega), \quad (5)$$

где f — сила осциллятора атомного перехода с резонансной частотой ω_0 , а γ — скорость релаксации возбуждения этого перехода. Сечение Р. с. атомом определяется из выражения (2), в к-ром полагается $\rho = \alpha E_0$, и равно

$$\sigma = 8|\alpha|^2 \omega^4 / 3\pi c^4. \quad (6)$$

Дисперсия Р. с. на атоме по-разному проявляется в разных диапазонах частот. В нерезонансной области, когда $\omega_0 \gg \omega$, как в большинстве случаев для видимого света, $\sigma \propto \omega^4$ (закон Рэлея). Эта зависимость играет гл. роль в эффектах окрашивания рассеянного света (начальное белого).

Вблизи атомных линий, когда $\omega \approx \omega_0$, Р. с. на резонансных ω . Макс. сечение в этом случае определяется величиной γ , значение к-рой не может быть меньше скорости радиац. релаксации:

$$\gamma = 2/e^2 \omega_0^3 / 3\pi c^2. \quad (7)$$

В этом предельном случае сечение Р. с. не зависит от f и определяется только длиной волны $\lambda_0 = 2\pi c/\omega_0$ и близко к $\sigma \approx \lambda_0^2/2$, что гигантски велико ($\sim 10^{-8}$ см² для видимого света) по сравнению с сечением нерезонансного рассеяния, имеющего порядок величины $\sigma_0 \omega^4/\omega_0^4$. Из-за узости спектральной области резонансного Р. с. оно различно для разных ширин спектра падающего излучения: если последняя уже ширины атомной линии, то в рассеянном излучении повторяется спектр падающего; при обратных условиях спектр рассеянного излучения имеет форму атомной линии. При этом обнаруживаются некогерентность и инерция Р. с. Отмечаются спектральные особенности резонансного Р. с. объясняются острой селективностью взаимодействия света с атомом, связанной с длит. затуханием возбуждения атомного осциллятора.

Р. с. на неподвижном атоме упругое и изотропное. Его индикатриса аналогична рассмотренной. Движение атомов вызывает неупругое Р. с. в соответствии с (4). Р. с. отд. атомами наблюдается в разреженных газах.

При Р. с. отдельными молекулами, в отличие от Р. с. атомами, в спектре рассеяния появляются новые, соседние с несмещённой, линии. Неупругое Р. с. молекулами наз. *комбинационным рассеянием света* (эффектом Рамана). Классич. теория объясняет это рассеяние внутримолекулярным движением, модулирующим электрону поляризуемость молекулы, что приводит к появлению спектральных спутников возбуждающей гармоникой и вместе с этим меняет интенсивность рассеянного света. Интенсивность спутников определяется глубиной модуляции поляризуемости и обычно составляет 10^{-6} и менее от интенсивности рэлеевской линии. Причём стоксовы компоненты рассеяния гораздо интенсивнее антистоксовых при темп-рате $T \ll \hbar|\omega - \omega'|/k$. Смещение линий $\Delta\omega = \omega - \omega'$ определяется частотами внутримолекулярных колебаний.

Др. отличие молекулярного Р. с. от атомного связано с анизотропной поляризуемостью молекулы. Из-за этого и вследствие произвольной ориентации свободных молекул в пространстве свет при рассеянии деполаризуется, а вращение молекул вызывает модуляцию угл. распределения интенсивности рассеяния, что, как и молекулярные колебания, формирует спектр неупругого Р. с. вблизи рэлеевской линии, т. е. её крыло шириной $\Delta\omega/2\pi c = 100 \sim 150$ см⁻¹ при комнатных темп-рах.

При Р. с. отдельными атомами и молекулами появ-

ляются особенности, связанные с влиянием конденсиров. среды на действующее на молекулу поле излучения и с возможностью переноса заряда при его разл. характере движений между молекулой и средой. Этим, в частности, вызывается сильное увеличение относит. интенсивности комбинационного Р. с. (см. *Гигантское комбинационное рассеяние света*).

Р. с. отдельными макроскопически малыми частями сам по себе произвольными относительно λ размерами порождает широкий класс явлений: радуги, гало, ореолы, расщепление дисперсных сред и др. Этот тип Р. с., называемый *Тиндалловым эффектом*, описывается полностью в рамках классич. теории, часто с использованием приближённых методов теории дифракции света.

Если поле падающего излучения мало искажается рассеянием, то описание рассеяния относительно просто. Эти случаи возможны, когда диэлектрич. проницаемости ϵ рассеивающих частиц и окружающей среды близки и частицы не слишком велики либо когда частицы малы по сравнению с λ . В первом случае поле рассеянного света рассчитывается суммированием полей элементарных диполей с учётом (3) и их интерференции. Этот метод даёт качественно правильные результаты, в частности в расчётах Р. с. большими молекулами, авеня цепь к-рых рассматривают как элементарные диполи.

Если размер частицы $< \lambda/10\sqrt{|\epsilon|}$, то она рассеивает как электр. диполь, наведённый момент к-рого $\mathbf{p} = \hat{\alpha} E_0$, где $\hat{\alpha}$ — тензор поляризуемости, пропорциональный объёму частицы, а зависимость $\hat{\alpha}$ от ϵ вещества частицы определяется её формой. Так, для сферич. частиц из оптически изотропного материала с радиусом $a < \lambda/20\sqrt{|\epsilon|}$ сечение Р. с. даётся формулой Рэлея:

$$\sigma = (4\pi/3)2^3 |\beta|^2 a^6 \omega^4 / c^4, \quad (8)$$

где $\beta = 3(\epsilon - 1)/4\pi(\epsilon + 2)$. Существенно, что частотная зависимость Р. с. в этом случае определяется двумя величинами — ω^4 и $|\beta(\omega)|$. Это Р. с. имеет рассмотренную выше индикатрису.

Если радиус a частицы велик и при этом $\lambda \gg a > \lambda/\sqrt{|\epsilon|}$, то падающее излучение индуцирует мультипольные моменты и дипольное приближение становится неприменимым. В предельном случае $\lambda \gg a \gg \lambda/\sqrt{|\epsilon|}$ (напр., при рассеянии ИК-излучения на металлических частицах) индуцируются электр. и магн. диполи одинаковы по величине. В этом случае сечение

$$\sigma = 10\pi a^6 \omega^4 / 3c^4 \quad (9)$$

качественно подобно рэлеевскому (8), но индикатриса этого Р. с. иная: свет рассеивается в осн. назад, а интенсивность света, рассеянного вперёд, составляет от него только $1/9$.

Описание Р. с. малыми частицами произвольных форм, размеров и диэлектрич. свойств математически трудно. Однако характерные закономерности рассеяния были установлены численно из строгой теории Р. с. на паровых частицах — т. н. теории М. и.

В этой теории два параметра: приведённый радиус частицы $ka = a\omega/c$ и $\sqrt{\epsilon} = n$ — комплексный показатель преломления среды частицы. При $ka \ll 1$ и небольшом различии показателей преломления среды частицы и окружающей рассеяние описывается ф-лами (2) и (8). Сечение имеет неск. максимумов в зависимости от радиуса. При $ka > 1$ сечение немонотонно зависит от ka (рис. 3), при этом величины максимумов σ зависят от n . Когда $n \approx 1$, первый максимум появляется при $ka = 2/(n-1)$ и может достигать $\sigma = 4\pi a^2$. Для полностью «отражающих» частиц ($|n| \rightarrow \infty$) первое макс. значение $\sigma = 2,3 \pi a^2$ появляется при $ka = 1,2$. В случае, когда $ka < 1$, но $nka \gg 1$, максимум

о появляются при $nka = j\lambda$ (где j — целое число и n — вещество) и достигают значений $\sigma = 6\pi a^2$ (резонансы М).

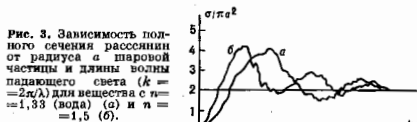


Рис. 3. Зависимость полного сечения рассеяния от радиуса a шаровой частицы и длины волны падающего света ($k = 2\pi/\lambda$) для вещества с $n = 1,33$ (вода) (а) и $n = 1,5$ (б).

С ростом ka при произвольных λ вариации σ уменьшаются и $\sigma \rightarrow 2\lambda^2$. Это отличие предельного σ от площади геом. тени λa^2 объясняется дифракцией, из-за к-рой на больших расстояниях от частицы граница тени широко размыта.

Индикатриса рассеяния по мере роста ka становится не симметричной (рис. 4), а вытягивается вперед. Немонотонность угл. распределения при $ka \gg 1$ появляется, начиная с $ka > \lambda$. Угл. распределение быстро и остро меняется по направлению и в зависимости от ka (и n и d в а т р и с в и з а ф ф е к т М и).

Так же резко меняется поляризация рассеянного света.

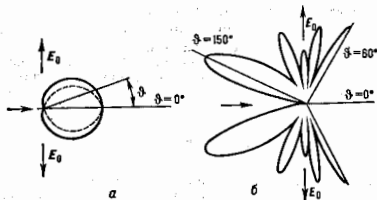


Рис. 4. Индикатрисы рассеяния линейно поляризованного света диэлектрическим шаром с $n = 1,25$ при $ka = 1,6$ (а) и $ka = 8$ (б). Сплошные линии соответствуют поляризации, перпендикулярной плоскости рассеяния, пунктирная — поляризация в плоскости рассеяния.

При $ka \gg 1$ Р. с. диэлектрич. частицами удовлетворительно описывается геом. оптикой с учётом интерференции лучей, падающих и последовательно отражённых и преломлённых на границах частиц. Так, без точкой структуры (напр., «ряби» на рис. 3) описываются радуги разл. порядков, ореолы и др. явления. Эффекты окрашивания рассеянного света (иначе говоря падающего — белого) объясняются при этом особенностями зависимости угл. распределения. Тонкая структура объясняется эффектами краевой дифракции, в частности «рябь» — интерференцией между волной, дифрагирующей на краю, и поверхностной волной, огибающей частицу.

Рассеяние света в средах. Практически всегда наблюдается Р. с. объектами с большим числом атомных частиц. Картина рассеяния создается в результате интерференции излучений вторичных волн отдельными атомными частями. Из-за большого их числа образуется мелкомасштабное пространственное распределение интенсивности рассеянного света. Практически эта тонкая структура рассеяния никогда не регистрируется, а усредняется, т. к. апертура регистрирующих устройств намного превосходит масштабы структуры. Поэтому Р. с. в средах описывается статистич. методами в форме усреднения по реализациям расположения рассеивающих атомных частиц.

В протяжённых и оптически плотных средах, кроме интерференции, существует др. коллективный эффект —

важное облучение частиц рассеянным излучением, называемое многократным Р. с. В гомогенной идеально однородной безграницной среде происходит полное интерференц. гашение излучения, рассеянного во всех направлениях всеми элементами среды, за исключением направления распространения падающей волны. Вместе с последней рассеянное излучение образует результирующее, распространяющееся как падающее со скоростью $< c$, определяемой показателем преломления среды. Эти утверждения, называемые теоремой Эвальда — Озена, справедливы для однородных сред при произвольной многократности Р. с. В ограниченной однородной среде Р. с., включая многократное проявление в виде граничных отражений света и преломления света и описывается соответствующими законами Снеллиа и Френеля.

Для неоднородной среды понятие многократного Р. с. связывается с взаимным облучением частей среды, называемым только её неоднородностью. Часто в качестве характеристики кратности Р. с. в среде без поглощения принимают *оптическую толщину*. Явления Р. с. в оптически толстых средах наиб. сложные для описания.

Принято разделять случаи Р. с. макроскопич. и микроскопич. неоднородностями. С первыми связывают Р. с. в разл. дисперсных средах и на шероховатых поверхностях, во вторых относят Р. с. в макроскопич. неоднородных средах, неоднородность к-рых названа флукутациями.

Рассеяние света макроскопич. неоднородностями — обычно многократное рассеяние в дисперсных средах. В оптически тонких дисперсных средах характер Р. с. определяется усреднёнными индивидуальными свойствами отд. частиц: размерами, формами, отличим их показателей преломлений от показателя преломления окружающей среды и т. д. Р. с. в оптически толстых дисперсных средах объясняются ур-ниями переноса плотности некогерентного излучения (см. *Перенос излучения*), для решения к-рых разработаны спец. численные методы.

Особый случай Р. с. макроскопич. неоднородностями представляет рассеяние шероховатыми поверхностями, масштаб рельефа поверхности к-рых сравним с λ (см. *Рассеяние волн на случайной поверхности*). Угл. спектр рассеянного излучения состоит из зеркально отражённой и диффузной составляющих. Угл. распределение диффузной составляющей излучения определяется пространственным спектром рельефа поверхности, видимо-го под углом падения. При скользких углах падения угл. спектр рассеяния сужается, что проявляется в характерном блеске поверхности, рассматриваемой под малыми углами. При многократном Р. с. на шероховатой поверхности диффузная составляющая становится почти изотропной, а зеркальная — исчезает. В этом случае поверхность выглядит матовой.

Молекулярное рассеяние света — рассеяние в макроскопич. однородных средах на микроскопич. неоднородностях — спонтанно появляющихся и исчезающих флукутаций термодинамич. параметров среды: плотности, темп-ры и т. п. При этом оптич. неоднородность изотропной среды определяется неоднородностью диэлектрич. проницаемости $\epsilon(r, t)$, в к-рой есть регулярная составляющая $\bar{\epsilon}$ и стохастическая $\tilde{\epsilon}(r, t) = \epsilon(r, t) - \bar{\epsilon}$, связанная с флукутациями термодинамич. параметров среды. Т. к. даже в оптически изотропной среде, в к-рой $\bar{\epsilon}$ — скалярная величина, возможны флукутации анизотропии, то $\tilde{\epsilon}(r, t)$ — величина тензорная.

Р. с. на диалектич. неоднородностях в оптически тонких средах определяется пространственно-временным спектром корреляторов $\langle \tilde{\epsilon}(r_1, t_1) \tilde{\epsilon}(r_2, t_2) \rangle$, в к-ром усреднение $\langle \dots \rangle$ проводится по всему ансамблю реализаций состояний среды. В однородной по пространству и во времени среде этот коррелятор зависит только от $|r_2 - r_1|$ и от $|t_2 - t_1|$ и характеризуется

величиной неоднородности (ϵ^2), её протяжённостью l_c и временем жизни τ_c , значениями, при к-рых коррелятор становится пренебрежимо малым, когда $|r_2 - r_1| > l_c$ и $|t_2 - t_1| > \tau_c$. Величина l_c определяет размер когерентно рассеивающей области или мин. расстояние между точками, фазы вторичных волн из к-рых можно считать статистически независимыми. Аналогичный смысл для временной области имеет характеристика τ_c . Пространственная и временная зависимости коррелятора определяют соответственно спектральные угловые и частотные характеристики Р. с.

Метод описания Р. с. в средах в терминах флуктуаций диалектрич. проницаемости правильный только условно. Некорректность его связана с тем, что диалектрич. проницаемость — это усреднённая характеристика среды, и о её пространственно-временных вариациях можно говорить определённо лишь когда их масштабы велики по сравнению с l_c и τ_c . Однако в большинстве случаев при описании Р. с. это соотношение выполняется. Корректный метод описания Р. с. в среде основывается на понятии микроскопич. поляризуемости и кинетич. ур-ния.

В разл. агрегатных состояниях характер флуктуаций различный, и в соответствии с этим различается Р. с. в них. В разреженных газах $\epsilon = 1 + 4\pi\alpha$, где $4\pi\alpha$ — объём, приходившийся на одну молекулу, а α — её поляризуемость. Флуктуации ϵ определяются флуктуациями α . Пространственное взаимное положение частиц в газе статистически независимо, поэтому длину корреляции l_c можно считать нулевой. Это означает, что фаза волны, рассеянной отд. частицей, не связана с остальными и интерференц. эффекты несущественны. Поэтому интенсивность рассеянного света равна сумме интенсивностей полей, рассеянных отд. молекулами. Если молекулы оптически анизотропны, то интенсивность рассеяния на каждой зависит от её ориентации относительно вектора поляризации падающего света. Поэтому, как и в случае отд. молекул, картина Р. с. в среде зависит от его поляризации. Рассеяние неполяризованного падающего излучения описывается коэф. рассеяния

$$R_{\rho, \theta} = \frac{2\pi^2}{\lambda^4} \rho(n-1)^2 \frac{\delta + \Delta\delta}{\delta - 7\Delta}, \quad (10)$$

в к-ром последний множитель определяет влияние анизотропии; для газа изотропных молекул он равен единице. Обычно $\Delta < 0,1$ и растёт с увеличением плотности.

Рэлеевская линия рассеянного в газе света уширена из-за связанного с движением частиц доплеровского эффекта. Уширение зависит от угла рассеяния θ и, согласно (4), его величина порядка $\Delta\omega \sim \omega(v/c)\sin\theta/2$, где v — средняя тепловая скорость молекул. Следует отметить, что спектр рассеянного вперёд света не уширен, а ширина спектра, рассеянного назад, — порядка доплеровской ширины атомной линии поглощения.

Резонансное Р. с. в газах обычно сопровождается *линейным излучением*. При этом происходит пространственные и спектральные преобразования излучения, приводящие, в частности, к явлению самообращения спектровых линий в рассеянном свете.

В жидкостях Р. с. в сечении на одну молекулу на один-два порядка меньше, чем в газах. Это объясняется меньшей сжимаемостью жидкостей и связанной с этим меньшей величиной флуктуаций ρ , к-рая, как и в газах, в осн. определяет флуктуации ϵ . С флуктуациями T обычно связано менее 1% рассеяния, т. к. движение молекул мало влияет на их поляризуемость. Протяжённость флуктуаций l_c в жидкости порядка неск. межмолекулярных расстояний, что гораздо меньше λ . Поэтому можно считать, что фазы волн, рассеянных каждым элементом объёма жидкости, независимы (как и в газе), но, в отличие от последнего, флуктуации числа рассеивающих молекул в этих объёмах не подчиняются закону Пуассона. Флуктуации ρ в жид-

костях в термодинамически равновесных условиях вызывают малые флуктуации диалектрич. проницаемости, в этих условиях коэф. рассеяния неполяризованного излучения равен

$$R_{\rho, \theta} = \frac{\pi^2}{2\lambda^4} kT\beta_T(\rho\delta/\partial\rho)^2 \frac{\delta + \Delta\delta}{\delta - 7\Delta}, \quad (11)$$

где $\beta_T = (\partial\rho/\partial p)_T$ — изотермич. сжимаемость. Зависимость $\epsilon(\rho)$ даёт разл. модельные теории кр. поля, однако не каждая из них даёт результаты, согласующиеся с экспериментом. Напр., использование в (11) зависимости $\epsilon(\rho)$ в виде *Клаузиуса — Моссооти формулы* не даёт согласия теории с экспериментом; наилучшее согласие с опытными данными получается для выражения

$$\rho\delta/\partial\rho = 3\epsilon(\epsilon-1)/(2\epsilon+1). \quad (12)$$

В жидкостях, в отличие от газов, движение частиц более сложное, и в нём выражен коллективный характер. Это определяет особенности временной эволюции флуктуаций и проявляется в спектрах неупругого (т. н. квазиупругого) Р. с. в жидкостях. Наиб. интенсивно Р. с. происходит на больших флуктуациях, затухание к-рых мало, напр. на упругих волнах, вызывающих соответствующую неоднородность показателя преломления (*Мандельштама — Бриллюэна рассеяние*). Это процесс неупругий, происходящий с изменением частоты света; в результате рассеяния монохроматич. излучения получается спектр, состоящий из несмещённой рэлеевской линии и дублета линий-сателлитов, симметрично удалённых от рэлеевской на величину $\Delta\omega$, зависящую от скорости v упругой волны и угла рассеяния θ :

$$\Delta\omega = \omega - \omega' = \pm 2\omega(v/c) \sin \theta/2. \quad (13)$$

В спектрах Р. с. в жидкостях выделяют близкую к рэлеевской линии область ($\Delta\omega/c < 1$ см⁻¹) тонкой структуры, область крыла рэлеевской линии (до 100–150 см⁻¹) и дальнюю область, спектр к-рой определяется внутримолекулярными движениями.

Тонкая структура, имеющая вид спектрального триплетта (рис. 5), объясняется двумя типами коллективных

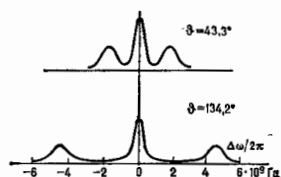


Рис. 5. Спектры рассеяния Мандельштама — Бриллюэна (тонкая структура рэлеевской линии) в CsI , для разных углов рассеяния.

движений: изотропными флуктуациями давления (звуком), к-рые вызывают в спектре дублет Мандельштама — Бриллюэна, и изобарич. флуктуациями, с к-рыми связана центр. компонента. Отношение интенсивности последней к сумме боковых определяется с хорошей точностью соотношением Лаандау — Плачека $I_T/I_s = (\epsilon_p - \epsilon_V)/\epsilon_p$, в к-ром ϵ_p и ϵ_V — изобарич. и изохорич. теплоёмкости соответственно. Для большинства жидкостей интенсивности всех компонент близки по величине, за исключением воды, в спектре тонкой структуры к-рой центр. компонента сильно подавлена при комнатной темп-ре и ниже. Это свидетельствует о квазикристаллич. структуре воды. Формы компонент триплетта близки к дисперсионным (лоренцевым контурам), и их ширины $\Gamma \sim \lambda^{-2} \sin^2 \theta/2$ пропорциональны скоростям затухания соответствующих флуктуаций

и связаны с дисперсией скорости гиперзвука в жидкости, т. к. наблюдаемое Р. с. происходит на колебаниях среды с частотами $\Delta\omega/c \sim 10^{10}$ Гц в области, где существенно меняется затухание флукуаций.

В плотных газах, но при длине свободного пробега молекул $l > \lambda$ одночастичные и коллективные флукуации плотности влияют на форму спектра в зависимости от угла рассеяния. Если $\sin\theta/2 \approx \lambda/l$, то линия имеет гауссову форму, как и в разреженных газах, с шириной, определяемой эффектом Доллера. При $\sin\theta/2 \approx \lambda/l$ начинает формироваться триплет, к-рый при $\sin\theta/2 \ll \lambda/l$ становится таким, как в жидкости.

При переходе от газа к жидкости в окрестности критической точки пар — жидкость характер Р. с. меняется: сильно увеличивается интенсивность рассеяния и центр компонента тонкой структуры спектра, индифферентно вытесняется вперед, меняется закон дисперсии. Это явление Р. с. — *опалесценция критическая* — бывает обычно многократным рассеянием, что проявляется в характерной для опалесценции мутности.

Особенности Р. с. вблизи критич. точки (критическое Р. с.) объясняется ростом флукуаций плотности и увеличением их размера l_c . Так, теория Орштейна — Зернике даёт выражение для коэф. рассеяния на изотропных молекулах в плоскости, перпендикулярной плоскости колебаний падающей волны:

$$R_0 = 2R_{n/2} [1 + \bar{v}\rho\beta_T l_c \lambda^{-2} (4\pi \sin \theta/2)^2]^{-1}, \quad (14)$$

где $R_{n/2}$ определено выражением (10) с $\Delta = 0$. В критич. точке $\beta_T \rightarrow \infty$ и интенсивность рассеяния определяется $R_0 \propto \lambda^{-2} \sin^{-2} \theta/2$, что показывает характер острого рассеяния вперед и дисперсию, отличную от релеевской. Область, в к-рой проявляется критич. Р. с., занимает интервал $\approx 1K$ около критич. точки. В ближайшей её окрестности Р. с. описывается теорией критических показателей, по к-рой коэф. рассеяния $R_0 \propto (1 + \cos^2 \theta) (\lambda \sin \theta/2)^{-1.66}$.

Р. с. в растворах вызывается не только флукуациями плотности, но и флукуациями концентрации. Закономерности этого Р. с. аналогичны тем, что получаются для чистых жидкостей, включая критические явления в окрестности точек расслоения и осаднения. Особенности критич. Р. с. в этих случаях связаны с образованием развитой поверхности раздела фаз, что сближает их с Р. с. на шероховатых поверхностях. Ввиду конечности значения \bar{v} вблизи точек расслоения и осаднения критич. явления в растворах менее подвержены влиянию веш. сил (в частности, гравитационным), чем системы пар — жидкость, и это делает растворы удобными системами для изучения критич. Р. с.

Критическое Р. с. наблюдается и в др. системах: растворах полимеров, жидких кристаллах, твёрдых телах и др., в к-рых при фазовых переходах резко возрастает флукуация поляризации среды.

Р. с. в твёрдых телах существенно отличается от Р. с. в жидкостях или растворах, что связано с большим разнообразием слабозатухающих флукуаций в виде упругих волн. В аморфном твёрдом теле могут распространяться два типа звуковых волн с разными скоростями: продольные, как в жидкости, и поперечные. С ними связаны два дублета в тонкой структуре релеевской линии, а центр компонента спектра релеевской линии, обусловленная беспорядочным расположением молекул в аморфной среде, очень узка из-за медленной (вследствие диффузии) эволюции беспорядка. В спектрах Р. с. в кристаллах центр компонента практически исчезает, а общее число компонент тонкой структуры определяется симметрией кристалла и условиями рассеяния: углами падения и рассеяния, поляризациями падающей и рассеянной волн. В аннотированном кристалле максимально возможное число компонент тонкой структуры 24: одна продольная и две поперечные упругие волны порождают 3 дублета, в к-рых каждая линия расщепляется в общем случае на 4 компонента

вследствие зависимости скоростей распространения падающей и рассеянной волн от их поляризации. При этом, чем симметричнее условия рассеяния и выше симметрия кристалла, тем меньше компонент обнаруживается в спектре.

Кроме упругих волн — акустич. фононов — в твёрдом теле есть и др. слабозатухающие коллективные движения — *квазичастицы*: плазмоны, экситоны, оптич. фононы и др., характеризующиеся законом дисперсии $\omega(\rho)$ и временем жизни. Когда число квазичастиц велико, Р. с. описывается классически, как результат модуляции показателя преломления среды соответствующими движениями в ней.

В квазичастичном описании Р. с. трактуется как соударение фотона с квазичастицей (рис. 1), если она имеется в нач. состоянии среды $|M\rangle$, или как рождение квазичастицы, если $|M\rangle$ — их вакуумное состояние. Если Р. с. связано в осн. с рождением квазичастиц, то спектры рассеяния несимметричны относительно релеевской линии: доминирует, как и при комбинационном Р. с. на молекулах, стоксова компонента. Такая картина наблюдается и вблизи релеевской линии при понижении темп-ры.

Ещё одна особенность Р. с. в твёрдых телах связана с сильным взаимодействием квазичастиц, что усложняет спектры неупругого Р. с.

Эксперим. исследование Р. с. в прозрачных средах на слабых флукуациях и выявление тонких особенностей спектров рассеяния затруднительно. Создание лазеров и совершенствование техники регистрации слабых световых потоков заметно уменьшили эти трудности, позволив наблюдать новые явления в Р. с.

Рассмотревшие выше типы Р. с. относились к излучениям малой интенсивности, недостаточной для заметного изменения состояния системы, на к-рой происходит рассеяние. При рассеянии мощного излучения обнаруживаются новые эффекты. Так, напр., при резонансном рассеянии высокоинтенсивного монохроматич. света на атоме (наиб. благоприятно для реализации эффекта сильного поля) спектр рассеяния при насыщении атомного перехода становится триплетом, что объясняется модуляцией рассеяния колебаниями атомной заселённости, вызываемыми падающим излучением.

При рассеянии интенсивного излучения в среде спонтанные процессы Р. с. могут усилиться стимуляцией излучением (индуцированное излучение). С таким *вынужденным рассеянием света* связан широкий круг явлений; напр., на вынужденном Р. с. основана работа комбинационного лазера. Если Р. с. стимулируется фотонами, рождёнными в среде в процессе рассеяния, то говорят о *вынужденном пассивном рассеянии*. Если Р. с. стимулировано веш. излучением, то его наз. активным вынужденным Р. с. (см. *Активная лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния, Нелинейная оптика*).

С классич. позиций, вынужденные процессы вызываются совм. раскачиванием падающей и рассеянной волнами когерентных колебаний в среде, модулирующих её оптич. характеристики.

Лазерная техника дала возможность достичь спектрального разрешения излучения до 10^4 см^{-1} . Это позволило изучать Р. с. от медленно движущихся частиц с целью установления их распределения по скоростям (доплеровская лазерная анемометрия) и разрешить тонкие особенности спектров рассеяния с помощью спец. разработанных методов оптич. гомодинамирования и гетеродинамирования (см. *Детектирование света*). Отличие этих методов от традиционных состоит в анализе не частотных спектров рассеянного поля, а спектров его интенсивности. Этот вариант нелинейной спектроскопии Р. с. даёт возможность исследовать высшие корреляторы поля (см. *Квантовая оптика*), что представляет большой интерес, т. к. статистика рассеянного излучения несёт информацию о строении веществ и процессах, происходящих в них.

Возможность сделать объём области рассеяния малым, но достаточно освещённым для наблюдений позволяет исследовать пространственные распределения частиц по статистике рассеянного света.

Явления Р. з. широко используются при разл. физ., хим., биол. исследованиях. Спектры Р. з. позволяют определять молекулярные и атомные характеристики веществ, в ряде случаев эти спектры служат единственными источниками информации о запрещённых переходах в молекулах. Р. з. широко используется для определения размеров, а иногда и форм мелких частиц, что важно для исследований атм. оптики и при лаб. исследованиях дисперсных систем. Вынужденные процессы Р. з. применяются в активной спектроскопии Р. з. и в лазерных системах для перестройки частоты.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Шифрин К. С., Рассеяние света в мутной среде, М.—Л., 1951; Вольфенштейн М. В., Молекулярная оптика, М.—Л., 1951; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Холст Г., Рассеяние света малыми частицами, пер. с англ., М., 1961; Фабелл и Сквилл И. Д., Молекулярное рассеяние света, М., 1965; Иваница А. П., Оптика рассеянного света, Минск, 1989; Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Френкель В. Е., Рассеяние света растворами полимеров, М., 1973; Вукс М. Ф., Рассеяние света в газах, жидкостях и растворах, М., 1977; Кроссби и др. Е. Ди Форо, П. Бертолотти М., Статистические свойства рассеянного света, пер. с англ., М., 1980; Рассеяние света в твёрдых телах, под ред. М. Кардонн, Г. Гонтротта, пер. с англ., в. 1—4 М., 1979—80; С. Г. Пржевальский, РАССЕЯНИЕ СВЕТА КОЭФФИЦИЕНТ — безразмерное отношение потока излучения, рассеиваемого данным телом, к падающему на него потоку излучения. См. также *Рассеяние света*.

РАССЕЯНИИ СВЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ — величина, обратная расстоянию, на к-ром поток излучения в виде параллельного пучка лучей ослабляется за счёт рассеяния света в среде в 10 (десятичный Р. с. п.) или в e (натуральный Р. с. п.) раз. Р. с. п. существенно зависит от длины волны света λ (частоты ν) рассеиваемого оптич. излучения.

РАССЕЯННЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ — звёздные скопления, населяющие диск Галактики. Звёзды Р. з. с. связаны общностью происхождения и имеют практически одинаковый возраст (10^8 — 10^9 лет) и хим. состав (близкое к солнечному содержанию тяжёлых им. элементов). Вследствие сравнительно небольшой массы Р. з. с. скорости хаотич. движений звёзд в них очень малы (доли км/с), что облегчает выделение членов скопления по *лучевым скоростям* и по собств. движениям (угл. смещение звёзд на небесной сфере) на плотном фоне окружающих скопления звёзд.

Изучение Р. з. с. важно для понимания происхождения и эволюции Галактики, потому что мн. характеристики (расстояние от Солнца, возраст и др.) определяются для Р. з. с. гораздо точнее, чем для звёзд галактич. поля. Возраст Р. з. с. определяется по цвету и абс. звёздной величине звёзд, расположенных вблизи точки изворота гл. последовательности на диаграмме Герцшпрунга — Расселла (см. рис. 4 в ст. *Герцшпрунга — Расселла диаграмма*); чем слабее эти звёзды, тем больше возраст, т. е. к скорости эволюции звёзд уменьшается с уменьшением их массы. Массивные звёзды в старых скоплениях давно ушли с гл. последовательности. Путём совмещения участков гл. последовательностей Р. з. с. близкого возраста определяется разность блеска звёзд одинаковой светимости и вычисляется относит. расстояние.

Расстояния до Р. з. с. задают галактич. *расстояний шкалу*. Особая роль в создании шкалы расстояний отводится известному Р. з. с. Гиады. Гиады принадлежат к числу т. н. движущихся скоплений с хорошо заметным радиантом (точкой на небесной сфере, куда направлены векторы видимых скоростей отд. звёзд). Для Р. з. с. с радиантом расстояние вычисляется с очень высокой точностью (2—3%), поэтому Гиады являются своеобразным «маяком», лежащим в основе определения всех галактич. (и даже внегалактич.) расстояний.

Молодые Р. з. с. (возраст 10^6 — 10^7 лет), населяющие диск в пределах 200 кп от плоскости Галактики, хорошо обрисовывают в окрестности Солнца отрезки спиральных рукавов Галактики, где и в настоящее время идёт интенсивное *звёздообразование*. Как правило, эти скопления не встречаются поодиночке и образуют группы, содержащие 2 и более скоплений. Такое распределение молодых Р. з. с. объясняется их совместным происхождением в звёздных комплексах, содержащих, помимо молодых скоплений и ассоциаций и ярких молодых звёзд, гигантские молекулярные облака и нейтральный водород. Своим мощным гравитат. полем звёздные комплексы ускоряют динамику, эволюцию и распад Р. з. с. Более старые Р. з. с. (образовавшиеся вск. млрд. лет назад) встречаются на расстояниях до 600 кп от плоскости Галактики, где они проводят заметную часть своей жизни.

Лит.: Холопов П. Н., Звёздные скопления, М., 1981; Звёздные скопления, в кн.: Итоги науки и техники, сер. *Астрономия*, т. 27, М., 1985. А. С. Расторгуев. **РАССЛОЕНИЕ** (расслоённое пространство) — одна из фундамент. структур, изучаемых в топологии. В совр. физике, гл. обр. в теории элементарных частиц, концепция Р. и ассоциированных с ним матем. структур (связность и т. п.) является наиб. адекватным языком для исследования нетривиальной топологии, возникающей при попытках описания взаимодействия между пространственными и внутренними степенями свободы физ. систем. Этот язык оказался полезным уже в простейших случаях, напр. в электродинамике, где нетривиальность топологии проявляется, в частности, в *Ааронова — Бома эффекте*. В неабелевых теориях *калибровочных полей* (типа *Янга — Миллса полей*) язык Р. вообще представляется единственным возможным при любых попытках выйти за рамки *возмущений теории*.

Расслоение $\xi = (E, p, F, B)$ — составной объект, включающий следующие элементы: пространство E — пространство P ; пространство B — база P ; непрерывное отображение (проектион) $p: E \rightarrow B$; пространство F — слой отображения. Над каждой точкой $x \in E$ можно определить полный прообраз $F_x = p^{-1}(x) \in E$. Множество F_x наз. слоем над точкой x . Слои над разл. точками должны быть гомеоморфными друг другу. Т. о., понятие слоя определено независимо от точек базы B . Размерность P наз. размерностью слоя F .

Локально P устроено как прямое произведение $B \times F$, т. е. для каждой точки $x \in B$ должны существовать окрестность V , $x \in V \subset B$ и гомеоморфизм φ , так что

$$\varphi: V \times F \rightarrow p^{-1}(V),$$

$$p\varphi(x', y) = x', \quad x' \in V, \quad y \in F.$$

В P можно определить обратное к p непрерывное отображение $s: B \rightarrow E$, такое, что $ps(x) = x$ для любой точки $x \in B$. Отображение s наз. сечением в P . Пространства E . Сечением прямого произведения $B \times F$ служат графики функций $B \rightarrow F$, $(x, s(x))$.

Наиб. интересные и важные в приложениях примеры связаны с P , у к-рых в слое определ. образом действует группа G преобразований (гомеоморфизмов) слоя F . Группа G наз. структурной группой P . Классич. примером нетривиального (отличного от прямого произведения) P является лист Мёбиуса m^2 . Базой P m^2 служит окружность S^1 , а слоем F — единичный отрезок I . В слое F действует циклич. группа Z_2 . Действие $G = Z_2$ задается в виде

$$g \cdot y = e^{2\pi} y, \quad g y = y, \quad g \neq e, \quad y \in F, \quad g \in Z_2. \quad (1)$$

Нетривиальное действие (1) группы Z_2 в слое F листа Мёбиуса определяет глобальное отличие P m^2 от тривиального (прямого произведения) P . $\pi = S^1 \times I$ (цилиндра), где действие группы Z_2 тривиально (тождественно).

Итутингово П. можно представить как объединение слоев $p^1(x)$, $x \in B$, параметризованных точками базиса и «склеенных» под действием группы преобразований слоя G (или более общо — топологии пространства E). Если действие G тривиально, то получаем тривиальное P .

Можно выделить два наиб. важных класса P . Векторные расслоения. Векторными P наз. P , ξ^n , у k -рых слоев есть векторное пространство Q , а группа G действует как подгруппа $GL(n, Q)$ группы всех линейных преобразований Q . Наб. существ. примеры являются вещественные P , $Q = R^n$, $G = O(n) \subset GL(n, R)$, и комплексные P , $Q = C^n$, $G = U(n) \subset GL(n, C)$. На векторных P выводится алгебраич. операция, характерные для векторных пространств, — тензорное произведение P и операция сложения, требующая более тонких рассуждений и называемая в теории P операцией Уитни.

Пример. Множество всех касательных векторов к двумерной поверхности M^2 образует двумерное векторное P (касательное P); $S^2 = TM^2$. Векторное поле на M^2 определяет сечение в P . TM^2 . Классич. теорема Пуанкаре утверждает, что единственное замкнутое многообразие M^2 , допускающее гладкое касательное поле без особенностей на M^2 , — тор T^2 . Нетрудно доказать, что теорема Пуанкаре включает следующие утверждения: только касательное P к T^2 есть прямое произведение.

Главные расслоения. P , ξ наз. главным, если слой P совпадает с группой G .

Пример. Рассмотрим тройку $\xi = (G, H, G/H)$. Здесь G — группа L_n , H — замкнутая подгруппа, G/H — фактор-пространство. Можно показать, что ξ является P с базой G/H , слоем H и пространством P , G .

$$p: G \rightarrow G/H.$$

В частности, если $G = SO(n)$, а $H = SO(n-1)$, то $G/H = S^{n-1}$.

P можно построить и в более общем случае $G \supset H \supset H_1$. Здесь H и H_1 — замкнутые подгруппы в G и H соответственно. Тройка $(G/H_1, H_1/H, G/H)$ является P . (H_1 — наиб. нормальный делитель группы H , принадлежащий H_1). Наб. важный пример P этого типа:

$SO(n-k) \rightarrow SO(n)/SO(n-k)$. Это P наз. нуклом сфер. Базой является пространство ортонормированных k -векторов в n -мерном пространстве Штифеля. Аналогично можно рассмотреть P с базой комплексного пространства Штифеля: $SU(n)/SU(n-k)$.

P с дискретным слоем F наз. накрытием. Напр., вещественная прямая R^1 служит накрытием над окружностью S^1 , $R^1 \rightarrow S^1$, слой $F = Z$.

Расслоение Хопфа. Классич. расслоение Хопфа задается отображением $p: S^3 \rightarrow S^2$, а слой $F = G = S^1$. Определим S^3 как множество пар комплексных чисел (z_1, z_2) с условием $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$. А поставим в соответствие паре (z_1, z_2) число $w = z_1/z_2$. Если $z_2 = 0$, то положим $w = \infty$. Множество $w \in C \cup \{\infty\}$ образует полную плоскость бесконечно удаленной точкой комплексную плоскость $C \cup \{\infty\} \sim S^2$. Т. к. точки $(z'_1, z'_2) = (\exp(i\varphi)z_1, \exp(i\varphi)z_2)$ и (z_1, z_2) отображаются в одну и ту же точку w на слой $F = S^1$. С классич. расслоением Хопфа и его обобщениями связаны фундам. достижения в математике. Напр., доказано, что существование только четырех алгебр с делением эквивалентно утверждению о существовании только четырех главных P вида $S^1 \xrightarrow{G} Sk \rightarrow S^1 \rightarrow S^1$, $S^2 \xrightarrow{S^1} S^3 \xrightarrow{S^1} S^4 \xrightarrow{S^1} S^5$. В физике расслоение Хопфа возникает при описании монополя Дирака.

В топологии разработаны спец. конструкции, позволяющие детально изучать глобальные характеристики расслоенных пространств. Осн. аппаратом является теория характеристик классов.

Расслоение в физике. Теория P находит применение в ряде разделов теории поля, теории конденсиров. сред и

гравитации. Наиб. интересны применения теории P в теории калибровочных полей, где P являются геом. конструкцией, адекватной идее калибровочного поля; точнее, калибровочное поле есть *сечение* в главном P со структурной группой G , определяющей калибровочные преобразования. Напр., в классич. электродинамике группа $G \sim U(1)$, а в теории Янга — Миллса G — полупростая группа L_n [$G = SO(2)$, $SU(2) \times U(1)$ и т. п.].

Фундам. вопросы теории калибровочных полей допускают геом. формулировку. Напр., согласно физ. принципу относительности, реальной физ. конфигурации отвечает класс калибровочных эквивалентных конфигураций. Условие выбора однозначного представления в каждом классе эквивалентных конфигураций, необходимое при вычислении континуальных интегралов, эквивалентно построению сечения в соответствующем P . Можно показать, что локально такие сечения всегда существуют. Однако глобальные сечения (калибровоч) построить нельзя. Этот важный результат (гробовские неоднозначности) следует из чисто топол. гич. рассуждений [теорема И. М. Зингера (I. M. Singer)]. При доказательстве теоремы Зингера используется техника бесконечномерных P .

Ряд важных физ. явлений допускает геом. интерпретацию, использующую понятие редукции P . Напр., теорию Максвелла рассматривают над физ. пространством Минковского — M^4 . Поля Максвелла определены над топологически тривиальным (сглаживаемым) пространством. Если же включить в теорию *магнитные монополи* (частицы с магн. зарядом, заданные в фиксиров. точках пространства M^4), то получим поле Максвелла над нестягиваемым пространством, напр. над S^2 (при наличии одного монополя). Др. пример редукции P связан с возможностью построения спец. классов полей и тем самым у-рий на многообразиях. Многообразие $на$, спинорным (обладает спинорной структурой), если структурная группа его касательного P может быть редуцирована от группы $SO(n)$ к $Spin(n)$. Необходимым и достаточным условием этого является обращение в нуль топол. инварианта (характеристик. класса), т. е. 2-го класса Штифеля — Уитни w_2 . Напр., комплексное проективное пространство CP^n имеет спинорную структуру только при четном n . Наличие спинорной структуры позволяет ввести на многообразии аналог Дирака уравнения. К изучению у-рий Дирака на n -мерных P приводит совр. проблемы *аномалий* в квантовой теории, разл. модификации теоремы об индексе Атьи — Зингера и т. п.

Новые приложения теории P получены в теории гравитации. Хотя гравитацион. поле и яе представляется в виде калибровочного поля (по типу эл.-магн. поля или поля Янга — Миллса), использование спец. класса P — *тензоров* Пенроуза позволяет продвинуться в решении совр. проблем квантовой гравитации.

Лит.: Стиррод Н., Топология носых произведений, пер. с англ., М., 1957; Стиллинг А. А., Файденс Л. Д., Введение в квантовую теорию калибровочных полей, 2 изд., М., 1988; Дубровини Б. А., Новиков С. П., Фомин А. Т., Современная геометрия, 2 изд., М., 1986; Миланор Д., Стайфел Д., Характеристические классы, пер. с англ., М., 1978; Тензорны и калибровочные поля, Сб. ст., пер. с англ., М., 1983; Геометрические идеи в физике. Сб. ст., пер. с англ., М., 1983; Шутц Б., Геометрические методы математической физики, пер. с англ., М., 1984. М. И. Монастырский.

РАССТОЯНИЙ ШКАЛА в астрономии — методы определения расстояний. Р. ш. необходима для нахождения размеров, светимостей и пространственного распределения изучаемых объектов. Такие фундам. открытия, как подобие звезд Солнцу, существование мира галактик, крупномасштабной структуры Вселенной и её расширение, явились результатом измерения соответствующих расстояний.

Исходным почти для всех методов измерения расстояний является геометрический метод — сопоставление размеров или скорости движения объектов и угловой и линейной мерах либо измерение угл.

перемещения объекта на небесной сфере (параллакс), обусловленного движением Земли или Солнца в пространстве. Фотометрический метод состоит в сопоставлении светимости объекта с его видимым блеском, убывающим поинверс. квадрату расстояния от него. Существует также множество вторичных методов. Расстояния в пределах Солнечной системы определяются радиолокационными методами. Базисом всей Р. п. во Вселенной служит ср. расстояние Земли от Солнца — астрономическая единица (а. е.).

Расстояния до ближайших звёзд определяются по их годичному параллаксу — большой полуоси эллипса, описываемого звездой на небесной сфере вследствие движения Земли вокруг Солнца. Годичный параллакс равен углу, под к-рым виден со звезды ср. радиус земной орбиты a . По определению, годичный параллакс π связан с расстоянием до звезды r (пк) соотношением

$$r = \frac{a}{\sin \pi} \approx \frac{a \cdot 206265}{\pi''} = \frac{1}{\pi''},$$

где π'' — параллакс в секундах дуги. Ближайшие к нам звёзды — α Кентавра и её далёкий спутник красный карлик Проксима (Ближайшая) Кентавра — находятся на расстояниях соответственно 1,34 и 1,32 пк. Обычная точность определения параллаксов — ок. 0,01", предельная — 0,005". Известны годовые параллаксы ок. 7500 звёзд, но лишь для 343 из них ошибки меньше 15%.

Запущенные на орбиту астрометрич. спутники повысят точность по крайней мере в неск. раз, но пока для определения расстояний, превышающих 50—100 пк, используют др. методы.

Для звёзд с измеримым собствен. движением μ (перемещение на небесной сфере в угл. секундах в год) определяют вековой параллакс, измеряя составляющую собствен. движения звезды, к-рая является отражением движения Солнца *авезу*. Этот способ применим только для групп звёзд, в к-рых остаются после учёта влияния галактик. вращения собствен. движения можно считать хаотическими ориентированными. При известных μ и лучевых скоростях v_r (км/с) для группы звёзд можно определить ср. параллакс, если предположить, что пекулярные пространственные скорости звёзд (остающиеся после учёта галактик. вращения) распределены изотропно. В этом случае параллакс π'' связан со ср. модулями μ и v_r соотношением $\pi'' = 4,74[\mu/v_r]$. Для звёзд диска Галактики пекулярные скорости малы и эти способы дают достаточно уверенные результаты до расстояний, не превышающих 1—2 пк.

Для более далёких расстояний используются фотометрич. методы, основанные на сравнении абс. M и видимых m звездных величин объектов. По определению звездной величины

$$1/I_0 = 2,512^{M-m} = (10/r)^2,$$

где I — блеск звезды на данном расстоянии r (пк) и I_0 — блеск на расстоянии 10 пк. Отсюда следует, что $I/r = 0,2(m - M) + 1$, где величина $m - M$ абс. модуль расстояния. Т. о., для объектов с известной M (определяемой светимостью объекта) возможна ахонждения расстояний ограничивается лишь предельной проникающей способностью телескопов; для «проникновения» в глубь Вселенной нужно знать светимости возможно более ярких (абсолютно) объектов. Необходимо также учесть ослабление видимой звездной величины вследствие *межзвёздного поглощения* света. Концентрация звёзд с высокой светимостью (сверхгигантов) мала, поэтому их нет в окрестностях Солнца; годовые параллаксы для них практически отсутствуют, а вековые и средние малы и ненадёжны. В связи с этим критерии, позволяющие находить светимости сверхгигантов, определяются по тем из них, к-рые входят в состав *рассеянных звездных скопле-*

ний. Расстояния до этих скоплений являются базисом Р. п. в Галактике и во всей Вселенной.

Исходными для построения системы расстояний рассеянных звездных скоплений служат расстояния до ближайших из них, определяемые геом. методом. Пространственные скорости звёзд в скоплениях параллельны друг другу (в пренебрежении орбитальными скоростями звёзд по сравнению со скоростью скопления как целого). Поэтому проекция на небесную сферу собствен.

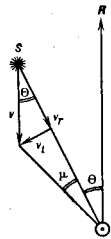


Рис. 1. Определение параллакса близкого скопления. R — направление на радиант; v — вектор пространственной скорости звезды; v_r — её составляющая по лучу зрения; μ — составляющая v на касательной плоскости, которая видна под углом θ , соответствующим собственному движению звезды.

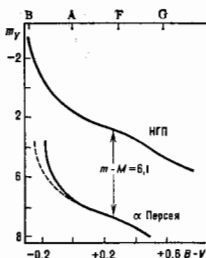
движений звёзд в достаточно близких скоплениях пересекаются в радианте. Сопоставление угл. расстояния члена скопления от радианта (θ) с собствен. движением и лучевой скоростью (рис. 1) позволяет определить параллакс каждой звезды в скоплении:

$$\pi'' = 4,74\mu/v_r \operatorname{tg} \theta.$$

К сожалению, достаточно близких скоплений лишь подожны, и только для Гиад этот групповой параллакс даёт расстояние с достаточной точностью. Поэтому крайний камень Р. п. является расстояние до Гиад. Оценки модуля расстояния этого рассеянного скопления заключены в пределах 3,29—3,45^m(45,4—48,8 пк).

Расстояния до более далёких рассеянных скоплений определяют др. методом. На диаграммах звездная величина — показатель цвета (см. *Астрофотометрия*) большинства звёзд в скоплении лежит в узкой полосе, называемой гл. последовательности (см. *Герцшпрунга — Рассела диаграмма*). На ней находятся звёзды, источником энергии к-рых служит превращение водорода в гелий (самая долг. стадия *эволюции звёзд*). После конца гравитацион. сжатия протозвезды и начала горения водорода светимость всех звёзд данной массы долгое время остаётся одинаковой, они находятся на нач. гл. последовательности (НГП). Её положение для всех скоплений в первом приближении одинаково. Для звёзд промежуточных и малых масс (*спектральных классов А, F и G*) абс. звездная величина (светимость) на НГП определяется непосредственно по расстоянию до Гиад. Совмещая с НГП гл. последовательности скопления, построенную в видимых звездных величинах, получают модуль расстояния соответствующего скопления, если в нём доступны наблюдениям достаточно слабые (маломассивные) звёзды (рис. 2). В общем случае наиболее удобное положение НГП, полученное подсоединением к гл. последовательности Гиад диаграмм более молодых скоплений, на гл. последовательностях к-рых массивные звёзды классов В и О ещё не успели отойти вверх (проволюционировать) от нач. положения. (В Гиадах эти массивные звёзды уже отсутствуют, поскольку быстро эволюционировали.) В этом методе предарительно учитывают разлчие хим. состава скопления и Гиад, а также поглощение света, к-рое для далёких скоплений, находящихся в плоскости Галактики, может достигать мн. звёздных величин. Для этого разрабатывают методы определения поглощения по многоцветной фотометрии звёзд в скоплениях, позволяющие разделить температурное и обусловленное погло-

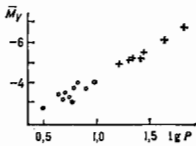
Рис. 2. Определение модуля расстояния скопления α Персея совмещением его главной последовательности (нижняя кривая; звездная величина — показатель цвета $B - V$) с начальной главной последовательностью (НГП), для которой звездные величины на диаграмме имеют смысл абсолютных. Вверху указаны соответствующие значения цвета спектральных классов. Штриховая линия — часть начальной главной последовательности, отсутствующая на диаграмме для скопления α Персея.



щением света увеличение (покаращение) показателя цвета звезд. Так определены расстояния до 450 скоплений Галактики. Совмещение гл. последовательности с начальной, прокалиброванной в абс. величинах, стало возможным и для скоплений в ближайших галактиках — Магеллановых Облаках, модуль расстояния скопления в Большом Магеллановом Облаке составляет $18,3 - 18,6^m$ ($45,7 - 52,3$ кпк).

В дожде рассеянных скоплений имеются пульсирующие желтые сверхгиганты — *цефеиды*, светимость k -рых связана с легко определяемым периодом изменения блеска. Эта зависимость (рис. 3) является следствием фундам. соотношений, связывающих массу и светимость звезд, а также их ср. плотность и период пульсаций. Наклон зависимости период — светимость определяется по цефеидам в близких галактиках, размерами

Рис. 3. Зависимость период — светимость (абсолютная величина), построенная для цефеид в рассеянных скоплениях (звезды) и OB -ассоциациях (красные) Галактики. M_p — средняя за период визуальная абсолютная величина, P — период.



k -рых можно пренебречь по сравнению с расстоянием до них, так что разность видимых звездных величин равна разности абс. звездных величин. Большая светимость позволяет обнаруживать цефеиды в близких галактиках (вплоть до расстояний в $5 - 7$ Мпк); известные по цефеидам расстояния до этих галактик можно использовать для определения светимостей ещё более «далекодействующих» индикаторов расстояния — ярчайших сверхгигантов, шаровых скоплений и диаметров зон III.

Большинство рассеяний в пределах нашей Галактики, зависимость скорости её вращения от расстояния до центра, локализации спиральных рукавов определяются P . ш. рассеянных скоплений и опираются на её P . ш. цефеид. Оценки расстояния до центра Галактики зависят от этих шкал, а также от независимой системы расстояний (ср. параллакс) пульсирующих переменных звезд типа RR Лир и шаровых звездных скоплений. Эти объекты относятся к сферич. составляющей Галактики и концентрируются к её центру, в отличие от цефеид и рассеянных скоплений, концентрирующихся, как и др. молодые объекты, к плоскости Галактики. Ср. параллакс звезд типа RR Лир определяется сравнительно надёжно. Эти звезды встречаются и в шаровых скоплениях, что даёт возможность определения расстояний до них. Метод совмещения наблюдаемой и начальной главной последовательности даёт для шаровых скоплений менее уверенные результаты, поскольку они в ср. наиболее далеко, чем рассеянные скопления, и их хим. состав существенно другой. Расстояние

до центра Галактики можно определить, в частности, как расстояние до центра симметрии распределения шаровых скоплений и звезд типа RR Лир и как расстояние до центра вращения. Для нахождения последнего используется P . ш. объектов галактич. диска и кривая вращения Галактики, для построения k -рой необходимыми получаемые радиометодами данные о распределении и лучевых скоростях облаков нейтрального, ионизованного и молекулярного водорода. В 1985 Международным астр. союзом расстояние от Солнца до центра Галактики принято равным $8,5$ кпк, вероятная ошибка этого значения составляет ± 1 кпк.

Возможности уточнения P . ш. в Галактике связаны, во-первых, с увеличением точности позиционных определений при измерениях в космосе и отчасти с широким применением наземных фотоэлектрич. наблюдений; во-вторых, с перспективой непосредств. определения радиуса цефеид наземными оптич. интерферометрами; в-третьих, с определением методами межконтинентальной радиоинтерферометрии собств. движений материальных источников (см. *Мазерный эффект* в космосе) в далёких областях звездообразования. Эти источники разлетаются радиально от формирующихся звезд, сопоставление собств. движений и лучевых скоростей позволяет определить расстояние. (Возможно, что существующую P . ш. надо сделать короче процентов на $10 - 15$; вопрос будет решён, вероятно, ещё в 20 в.)

Наличие больших систематич. ошибок P . ш. внутри Галактики и ближайших галактиках представляется исключённым. Это следует, в частности, из согласования полностью независимых оценок расстояний до Магеллановых Облаков и галактики Андромеды, определяемых по цефеидам и по звездам типа RR Лир. Недавнее обнаружение этих звезд (при звездной величине $25,7^m$ в синих лучах) в галактике Андромеды явилось триумфом наземной оптич. астрономии; определённый с их помощью модуль расстояния этой ближайшей к нам галактики спиральной галактики составляет $24,3^m$ (700 кпк), что не более чем на $0,2^m$ отличается от значения, полученного с помощью цефеид.

Независимо от цефеид и звезд типа RR Лир P . ш. близких галактик дают новые звезды, их светимость в максимуме блеска связана со скоростью его уменьшения. Эту зависимость можно прокалибровать в Галактике по скоростям расширения оболочек или «ветерного ха» от всплеск новых звезд. Новые звезды регистрируются даже в галактиках скопления в созвездии Девы, при модуле расстояния $30 - 31^m$ ($10 - 16$ Мпк), но обнаружение всплески и построение кривой блеска требует длит. наблюдений. Практически более важными индикаторами расстояния являются ярчайшие сверхгиганты; для голубых звезд абс. величина составляет ок. -9^m (что близко к абс. величине новых в максимуме блеска), однако она является ф-цией интегральной светимости родительской галактики. Этого недостатка лишены красные сверхгиганты, светимость k -рых поскоку составляет ок. $-8,0^m$. Характеристики ряда др. индикаторов расстояния также зависят от светимости входящей их галактики и (или) интенсивности звездообразования в них. Это относится к светимости набр. ярких шаровых скоплений и диаметрам наибольших в галактике зон III и объясняется в осн. влиянием различия величин выборки. Более обременяющей является обнаруженная недавно корреляция светимости зон III с дисперсией скоростей газа в них.

Расстояния до далёких галактик, в k -рых индивидуальные объекты неразличимы (далее $10 - 15$ Мпк), определяются с малой точностью. Наиб. значение имеют динамич. методы, основанные на корреляции между массой и светимостью галактик. Индикатором массы служат макс. скорость вращения галактики и определяемая ею дисперсия наблюдаемых скоростей звезд (находится по пириные линии поглощения в спектре галактики) или, чаще, нейтрального водорода.

Для ещё более удалённых галактик становится возможным применение *Хаббля закона*, связывающего расстояние галактик r со скоростью v_r , соответствующей её красному смещению z , $cz = v_r = Hr$. Определённые значения H являются отдельной сложной проблемой, в частности из-за необходимости учитывать и не связанные с расширением Вселенной движения скопления галактик. Продолжающаяся дискуссия между сторонниками длинной ($H = 50$ км/с·Мпк) и короткой ($H = 100$ км/с·Мпк) H ш. в существ. степени объясняется ненадёжностью определений расстояний до близких галактик и эффектом селекции далёких галактик (преим. наблюдаются наиб. яркие галактики).

Лит.: Холлоуэй П. В., Звездная астрономия, М., 1984; Кутяковская П. П., Звездная астрономия, 2 изд., М., 1985; Ефремов Ю. Н., Огни звездообразования в галактиках, М., 1989.

Задача определения расстояний до тел Солнечной системы обычно рассматривается как задача определения движения тел Солнечной системы и установления масштаба измерения — астрономической единицы e и 1 а.е., обозначаемой a или a е. Астр. единица определяется как полусумма орбиты планеты с пренебрежимо малой массой, к-рая, двигаясь в гравитационном поле одного только Солнца, имеет ср. угол движения $(2\pi/T)$, где T — период обращения вокруг Солнца, равное 0,01720209895 радиан [1].

Методы наблюдений, лежащие в основе определения расстояний до тел Солнечной системы, можно разделить на классич. оптич., радиотехн. и лазерную локацию.

К классич. оптич. методам относятся наблюдения угл. положений тел Солнечной системы относительно опорных звёзд. Движение тел и значение a определяются этими методами до развития радиотехн. методов. Величина a находилась из астрометрич. наблюдений суточного горизонтального экваториального параллакса Солнца ρ_0 . Он связан с a соотношением

$$a_3 = a \sin \rho_0,$$

где a_3 — экваториальный радиус Земли. Параллакс Солнца по оптич. наблюдениям определялся тригонометрич. и динамич. методами. Тригонометрич. метод аналогичен методу триангуляции для определения расстояний на поверхности Земли. Динамич. метод основан на определении движения малых тел Солнечной системы по позиционным наблюдениям при их прождении вблизи Земли. Ввиду малой точности (погрешность 10^4 км) оптич. методы для определения a ныне не применяются.

Точность определения расстояний в Солнечной системе значительно повысилась с использованием радиотехн. методов. К ним относятся: радиолокация планет (см. *Радиолокационная астрономия*), впервые проведённая в 1958, измерения дальности до комет, аппаратов и измерения доплеровского смещения частоты сигнала. Особый тип радиотехн. наблюдений представляет собой наблюдения с использованием *радиотермометров* со сверхдлинными базами. При использовании радиотехн. методов посылают радиопульсы к исследуемому объекту и принимают отражённый или (в случае измерения дальности до комет, аппарата) ретранслированный сигнал. В результате получают время запаздывания отражённого или ретранслированного сигнала и доплеровское смещение частоты. Считая, что скорость света и условия распространения сигналов в пространстве известны, вычисляют расстояние между Землёй и исследуемым объектом. Наиб. точность измерения расстояний радиотехн. методами достигнута при определении дальности до посадочного аппарата «Викинг» (США), находящегося на поверхности Марса (погрешность ~ 5 м на расстоянии ~ 1 а.е.).

В методе лазерной локации используются угольные отражатели. Впервые этот метод был применён для Луны (1969). Погрешность лазерных измерений расстояний до угольных отражателей на поверхности Луны составляет ≈ 50 см.

Задача построения общей теории движения планет Солнечной системы решается как комплексная задача изучения движения тел системы с привлечением всех доступных видов наблюдений. Одной из последних теорий является теория движения планет и Луны DE200/LE200, разработанная коллективом учёных Лаборатории реактивного движения (США) [3]. Для моделирования движения использовалось численное интегрирование у-р движения с учётом всех возмущений. Один из определяемых параметров этой теории — астр. единица. Погрешность определения a в этой теории ≈ 30 м ($a = 149597870,884 \pm 0,03$ км).

Лит.: 1) Абалякин В. К., Основы эфемеридной астрономии, М., 1978; 2) Погобеда В. В., Ефремов В. В., Общая астрономия, 2 изд., М., 1982; 3) Newhall X. X., Standish E. M. Jr., Williams J. G., DE 102: a numerically integrated ephemeris of the Moon and planets spanning forty-four centuries, «Astron. and Astrophys.», 1983, т. 125, p. 150.

РАСТВОРИМОСТЬ — способность вещества образовывать с др. веществом *раствор*. Количественно характеризуется концентрацией вещества в насыщенном растворе. P определяется физ. и хим. средством молекулярности и растворённого вещества, к-рое характеризуется т. в. энергетич. взаимодействием молекул растворителя. Как правило, P велика, если молекулы растворённого вещества и растворителя обладают сходными свойствами («подобное растворяется в подобном»). Зависимость P от темп-ры и давления устанавливается с помощью *Ле Шателье — Брауна принципа*. P возрастает с ростом давления и проходит через максимум при высоких давлениях; P газов в жидкостях с ростом темп-ры падает, в металлах растёт.

РАСТВОРЫ — системы, состоящие из молекул, атомов (и/или) ионов неск. разл. типов, при этом числа разл. частиц не находятся в к-л. определённых стехиометрич. соотношениях друг с другом (что отличает P от хим. соединений). К P обычно относят такие многокомпонентные системы, в к-рых при неизменных внеш. условиях достигается состояние термодинамич. равновесия.

Агрегатное состояние P может быть твёрдым (*твёрдые растворы*), жидкокристаллическим (*жидкие кристаллы*), жидким или газообразным. Будучи макроскопически пространственно однородными, на молекулярных масштабах P могут обладать своеобразной микроструктурой (микрорегулярные растворы, или ассоциирующие коллоиды), к-рая определяется темп-рой, давлением и составом P . Если микроструктура P является регулярной (в одном, двух или трёх измерениях), то его относят к *лиотропным жидким кристаллам*. Жидкие P с нерегулярной микроструктурой (обычно многокомпонентные, содержащие органич. вещества и соли) наз. *эмульсиями* (микроземьями). Суспензиями частиц размером от неск. нм до тысяч нм относят к *коллоидным P*.

В том случае, когда молекулы растворённого вещества диссоциируют на ионы, P относят к особому классу — *P полимерного*. Отличит. свойствами обладают *P. полимерного*.

Термодинамические свойства растворов
Термодинамич. свойства P описываются общими для многокомпонентных систем соотношениями термодинамики. Число веществ l , кол-ва n -рых в состоянии полного термодинамич. равновесия могут быть заданы произвольно, наз. числом независимых компонент P . Если число молекул (атомов) одной из компонент системы N намного превышает числа N_1, \dots, N_{l-1} молекул остальных компонент, P наз. разбавленным (слабым). Вещество, содержащее N частиц, в этом случае наз. *растворителем*, остальные компоненты — *растворёнными веществами*. Величины

$$c_i = N_i/N \quad (\text{здесь } N = \sum_{i=1}^{l-1} N_i) \quad \text{наз. молярными (молеку-$$

ларными) концентрациями (используя также весовые и объёмные концентрации). Согласно Гиббса *правилу фаз*, в системе, состоящей из n компонентов, в равновесии не может находиться более $n + 2$ фаз. Состояние P , описывается $n + 1$ переменной ($n - 1$ значение концентрации, темп-ра T и давление p) и может быть изображено точкой в $n + 1$ -мерном пространстве. Если в этом пространстве построить гиперповерхности меньшего числа измерений, на к-рых выполняются условия равновесия двух или большего числа фаз, то получится поверхность, характеризующая состояние системы, — т. н. фазовая диаграмма системы (или *диаграмма состояний*). Обычно пользуются сечениями фазовой диаграммы различными плоскостями.

Диаграммы плавления и кипения растворов. В отличие от чистых веществ, изменение агрегатного состояния P . происходит в нек-ром интервале изменения концентрации компонент, темп-ры (i) или давления. Простейший случай равновесия двух фаз реализуется, когда обе компоненты, образующие P ., в обеих фазах смешиваются в произвольных отношениях. Кривые равновесия в этом случае не имеют максимумов и минимумов и образуют характерную «сигару» (диаграмма $T - c$, c — концентрация; рис. 4). Пусть для определения рассматриваемые фазы представляются собой жидкость (низкотемпературная фаза II) и пар (высокотемпературная фаза I). Если изображающая точка системы (T, c) лежит выше кривой FAG , то агрегатное состояние системы — пар, если ниже кривой FCG — жидкость. Заптрихованная область между кривыми FAG и FCG соответствует равновесию двух фаз (представляющих собой т. н. насыщенные растворы), концентрации к-рых характеризуются растворимостью веществ и равны c' и c'' , в точке B массы определяются «правилом рычага», согласно к-рому кол-во молекул в фазах I и II обратно пропорциональны длине отрезков соответственно AB и BC :

$$\frac{N_1^I + N_2^I}{N_1^I + N_2^I} = \frac{c'' - c_0}{c' - c_0}$$

В случае равновесия системы жидкость — пар кривая FAG наа. кривой конденсации, а FCG — кривой кипения. В случае равновесия твёрдой и жидкой фаз кривая FAG наа. кривой ликвидуса, а FCG — кривой солидуса.

Фазовые диаграммы типа «сигары» дают P . веществ, близких по хим. свойствам: для диаграмм плавления — это, напр., бинарные (двухкомпонентные) растворы $Ge - Si$, $Ag - Au$, $Cu - Ni$, $AgCl - NaCl$, для диаграмм кипения — системы бензол — толуол, этиловый спирт — вода и др. При относительно небольшом хим. отличии смешиваемых веществ A и B кривые кипения и конденсации могут иметь максимум или минимум, в к-ром эти кривые касаются друг друга (рис. 2). P . состав к-рого соответствует точке касания (точка A), наз. азеотропным. Фазовый переход (кипение или плавление) в P . такого состава происходит так же, как в чистом веществе, — целиком. Когда точка касания является максимумом кривых равновесия (рис. 2, а), кипение P . произвольного нач. состава приводит к смещению изображающей точки системы в положение A . Т. о., азеотропная точка является устойчивой предельной точкой процесса кипения. Если же касание кривых равновесия происходит в их минимуме (рис. 2, б), то в процессе фазового перехода при повышении

темп-ры изображающая точка системы сдвигается к одному из чистых веществ; азеотропная точка достигается при охлаждении смеси

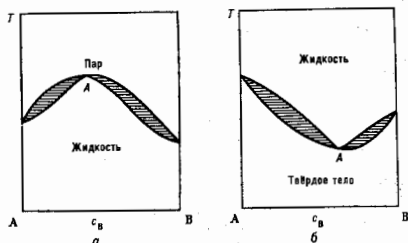


Рис. 2. Примеры диаграмм состояний: а — теплота смешения в жидкости меньше, чем в паре; б — теплота смешения в твёрдой фазе больше, чем в жидкой.

При повышении p в системе жидкость — пар форма «сигары» изменяется, а при давлениях выше критической (см. *Критическая точка*) для одной из компонент, когда отсутствует различие между двумя фазами этого вещества, «сигара» вырождается в петлю путём смыкания кривых кипения и конденсации в нек-рой (критической) точке (рис. 3).

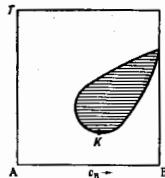


Рис. 3. Пример диаграммы состояний двухкомпонентной системы жидкость — пар в случае, когда давление в системе превышает критическое давление компонента A . Разделение смеси на жидкую и газообразную фазы имеет смысл лишь в пределах заптрихованной области. K — критическая точка.

Диаграммы смешения растворов. Наряду с равновесиями фаз, находящимися в различных агрегатных состояниях, в P . могут сосуществовать фазы, находящиеся в одном агрегатном состоянии, напр. жидком. На рис. 4 изображена диаграмма, соответствующая случаю ограниченной смешиваемости двух веществ в одной

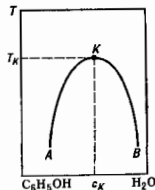


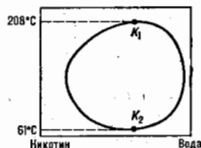
Рис. 4. Диаграмма смешения системы фенол — вода. K — критическая точка смешения с параметрами $T_K = 66^\circ C$, $c_K = 0,65$.

жидкой фазе. Жидкости полностью смешиваются в области, лежащей над кривой AKB , и ограничено смешиваются в области, лежащей под этой кривой (где имеет место расслоение P . на две жидкие фазы с составом, определяемым «правилом рычага»). Точка K максимума кривой — критическая; в окрестности этой точки наблюдаются аномалия теплоёмкости, критич. опалесценция и др. *критические явления*. Сосуществуют жидкие системы (напр., триэтиламин — вода), для к-рых область неограниченной смешиваемости лежит ниже нек-рой кривой и к-рые имеют минимумы темп-ры

смешения, а также системы, имеющие как верхнюю, так и нижнюю тем-ры смешения (рис. 5).

Верхняя критич. тем-ра смешения растёт с увеличением различий хим. свойств смешиваемых веществ.

Рис. 5. Диаграмма смешения системы никотин — вода. Жидкости подобно смешивают в области, ограниченной замкнутой кривой.



Качественно эта зависимость выражается в понятии микростроения ряда, в к-ром все вещества располагаются в соответствии со значением приписываемого каждому из них т. н. эффективного заряда e (табл.); численные значения e получены не для всех веществ, но они расположены в порядке убывания e . Верхняя тем-ра смешения растёт с увеличением разности зарядов смешиваемых веществ.

Микростроение ряд

Вещество	Химическая формула	Эффективный заряд e , в отнотс. ед.
Вода	H ₂ O	48
Молочная кислота	CH ₃ CH(OH)COOH	
Формальд.	NH ₂ CHO	
Муравьиная кислота	HCOOH	
Уксусная кислота	CH ₃ COOH	
Метанол	CH ₃ OH	29
Этанол	C ₂ H ₅ OH	26
Аммиак	C ₂ H ₅ NH ₂	24
Ацетон	CH ₃ COCH ₃	20
Диоксан	(C ₂ H ₄ OCH ₂) ₂	20
Пиридин	C ₅ H ₅ N	
Эфир этиловый	C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅	
Хлороформ	CHCl ₃	
Дихлорэтан	(C ₂ H ₄ Cl) ₂	20
Бензол	C ₆ H ₆	19
Толуол	C ₆ H ₅ CH ₃	18
Четырёххлористый углерод	CCl ₄	
Диплолэтан	C ₂ H ₆	
Гексан	CH ₂ (CH ₂) ₄ CH ₃	
Октан	CH ₂ (CH ₂) ₆ CH ₃	15

Если верхняя критич. тем-ра смешения веществ в низкотемпературной фазе оказывается выше тем-ры минимума кривых равновесия, изображённых на рис. 2 (б), то фазовая диаграмма системы приобретает вид, аналогичный изображённому на рис. 6. Такая диаграмма принадлежит к эвтектическому типу; Р.,

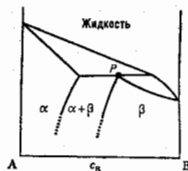
Рис. 6. Фазовая диаграмма системы Zn — Pb эвтектического типа. α , β — твёрдые растворы. Точка пересечения трёх линий, в которых сосуществуют жидкая и две твёрдые фазы, — точка эвтектики.



имеющий E , состав, отвечающий точке эвтектики происходит при определ. тем-ре, как и плавление химически чистого вещества. В Р. с ограниченной взаимной растворимостью могут возникнуть также фазовые диаграммы перитектического типа (рис. 7). Перитектическая точка имеет самую высокую тем-ру плавления определённой твёрдой фазы, в то время как точка эвтектики — наименьшую тем-ру затвердевания определённой жидкой фазы. Эвтектичес-

кая и перитектическая точки — это точки сосуществования трёх фаз: жидкой и двух твёрдых.

Рис. 7. Фазовая диаграмма перитектического типа. Р — перитектическая точка, α, β — твёрдые растворы.



Законы слабых растворов. Термодинамический потенциал слабого Р. имеет вид

$$\Phi = N \left[\mu_0(P, T) + \sum_i c_i T \ln(c_i/c_i^0) + c_i \psi_i(P, T) \right],$$

где $\mu_0(P, T)$ — химический потенциал чистого растворителя; $\psi_i(P, T)$ — век-рая ф-ция, зависящая от природы растворителя. Растворённое вещество распределяется между разл. фазами т. о., что отношение концентраций c_1 и c_{11} в этих фазах зависит лишь от P, T , но не от полного кол-ва растворённого вещества (т. н. закон распределения):

$$c_1/c_{11} = \exp[(\psi_{11} - \psi_1)/T].$$

В частности, когда одна из фаз представляет собой газ, имеет место *Генри закон*, согласно к-рому концентрация слабого Р. пропорциональна давлению газа p .

При растворении в жидкости летучего вещества давление p насыщенного пара над Р. меньше, чем давление над чистым растворителем p_0 :

$$p_0 - p = p_0 v' / v \quad (1)$$

(*Рауля закон*), где v' и v — числа молей растворённого вещества и растворителя в единице объёма Р. По отношению к летучему веществу поверхность жидкости ведёт себя как непроницаемая перегородка, и (1) представляет собой частный случай выражения для осмотического давления (см. *Осмоз*) слабых Р. При этом между частями системы, разделёнными перегородкой, применимой для растворителя, но непроницаемой для растворённых веществ, возникает разность давлений

$$\Delta p = (T/V) \sum_{i=1}^{n-1} N_i,$$

где V — объём части сосуда, занятой растворёнными веществами.

Из закона Рауля (1) следует, что при пост. давлении тем-ра кипения P, T_K' выше тем-ры кипения чистого растворителя T_K :

$$T_K' = T_K + \frac{v'}{v} \frac{RT_K^2}{\mu_{KL} v},$$

где μ — молекулярная масса веществ растворителя, $\mu_{KL} v$ — уд. теплота испарения. Тем-ра замерзания Р. T_0' ниже тем-ры замерзания T_0 чистого растворителя:

$$T_0' = T_0 - \frac{v'}{v} \frac{RT_0^2}{\mu_{GL} v},$$

где $\mu_{GL} v$ — уд. теплота плавления.

Ассоциирующие растворы

Мицеллообразование. Физ.-хим. свойства Р. широкого класса веществ, молекулы к-рых имеют асимметрич. форму, — т. н. амфифильные вещества (наз. также дифильными или *поверхностно-активными веществами*), определяются образованием в них т. н. мицелл —

агрегатов молекул растворённого вещества. Такие Р. наз. м. и ц. е. л. р. м.

Амфифильные вещества имеют вытянутые молекулы (часто линейные) длиной 20—30 Å, имеющие хорошо выраженные гидрофильные или олеофильные (жирные, гидрофобные) части (см. *Гидрофильность и гидрофобность*). К таким веществам относятся соли жирных к-т (напр., мыло — стеарат натрия), имеющие в составе молекулы гибкую парафиновую цепь $C_{17}H_{33}$ или $C_{18}H_{37}$ («жирный хвост»), присоединённую к полярной группе — «головке». «Головка» образована группой атомов, соединённых полярными связями. Амфифильными молекулами являются также липиды и фосфолипиды, входящие в состав клеточных мембран (см. *Клеточные структуры*).

Участок диаграммы состояния Р. амфифильного вещества приведён на рис. 8. Кривая равновесия ABC отделяет области жидких фаз I (молекулярный Р.) и II (мицеллярный Р.), или ассоциирующий коллоид, см.

Рис. 8. Диаграмма состояния раствора амфифильного вещества вблизи точки мицеллообразования. T_K — температура Крафта; I — молекулярный раствор; II — мицеллярный раствор; III — кристалл.



ниже) от твёрдой фазы III. Области молекулярного и мицеллярного Р. разделены нек-рой переходной областью BD, а не линией, как в обычном случае равновесия двух фаз. Мин. темп-ра T_K , при к-рой возможно образование мицелл, наз. темп-ратурой Крафта. Концентрация амфифильного вещества c^* , при к-рой начинается образование мицелл, наз. критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). ККМ сильно зависит от темп-ры, ионной силы Р. (сумма значений концентраций всех ионов Р., умноженных на квадрат их зарядов) и т. д. ККМ падает с ростом длины «жирного хвоста» молекулы приближённо линейно при числе атомов углеводородной цепи $n < 10-15$; при больших n возможно отклонение от линейного закона. Характер изменения нек-рых физ. свойств Р. при мицеллообразовании представлен на рис. 9.

Форма и структура мицелл зависят от типа растворителя (полярный или гидрофобный), от концентрации

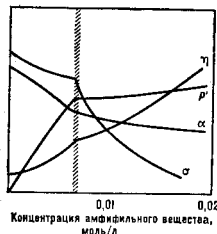


Рис. 9. Изменение осмотического давления раствора (ρ), коэффициента вязкости (η), электропроводности (σ) и поверхностного натяжения (α) вблизи критической концентрации мицеллообразования c^* ; для раствора додецилсульфата натрия ($C_{12}H_{25}OSO_3Na$) в воде $c^* = 8 \cdot 10^{-3}$ см 3 .

Р., его состава, темп-ры и др. Бóльши ККМ форма мицелл близка к сферической. В полярной среде (напр., в воде) мицеллы имеют углеводородное ядро, а полярные «головки» обращены к молекулам воды. В жирной среде мицелла имеет обратную структуру: полярные «головки» образуют ядро, а олеофильные «хвосты» контактируют с растворителем (рис. 10). Каждая мицелла в Р. содержит 20—100 молекул амфифильного веществ

ва (т. н. число агрегации). Обычно часть полярных «головок» молекул диссоциирована на ионы (для ионногенных амфифильных веществ).

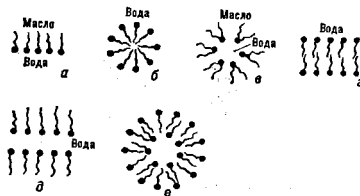


Рис. 10. Структура агрегатов в растворах амфифильного вещества: а — гидрофильная монослой на поверхности раздела жирной и полярной сред; б — сферическая мицелла в полярном растворителе; в — обобщённая сферическая мицелла в жирной среде; г — ламелла (двойной) в полярной среде; д — обобщённая ламелла (мыльная плёнка); е — дуэрект (вежулка), образованный в полярной среде.

С ростом концентрации Р. форма мицелл может изменяться: они принимают цилиндрическую, дискообразную форму или форму трёхосного эллипсоида. Это проявляется в изменении *индикатрисы* рассеяния света Р. и в изменении зависимости *вязкости* Р. от концентрации. В нек-рых случаях в Р. могут присутствовать цилиндрич. мицеллы, содержащие $\sim 10^8-10^4$ молекул. В области концентраций Р., превышающих ККМ, именно мицеллы являются элементарными структурными единицами, определяющими физ. свойства возникающих в Р. фаз, как изотропных, так и жидкокристаллических (см. ниже).

Надмолекулярные жидкокристаллические структуры в растворах. Подобно молекулярным, мицеллярные Р. при нек-рой концентрации мицелл могут расслаиваться. Вблизи критич. точек расслоения (н-рые могут быть как верхними, так и нижними) наблюдаются критич. явления. Отслаивающаяся при увеличении концентрации более плотная фаза может быть как изотропной, так и анизотропной (см. *Жидкие кристаллы*). В бинарных системах обычно возникает гексагональная, ламеллярная (смектическая) и (или) кубическая фазы. Переход между ними происходит вследствие изменения формы или (и) размеров мицелл.

Гексагональные фазы образованы цилиндрич. мицеллами неопределённой длины, упакованными в двумерную решётку, имеющую гексагональную симметрию (рис. 11). Структура мицелл может быть нормальной или обратной в зависимости от типа амфифильного вещества и растворителя. Радиус нормальных цилиндрич. мицелл примерно на 10—30% меньше длины полностью вытянутой амфифильной молекулы, расстояние между цилиндрами в зависимости от содержания воды варьируется в пределах 8—50 Å. Для обратных мицелл диаметр водного цилиндра составляет 10—20 Å, расстояние между ними ок. полутора длины «жирных хвостов» амфифильных молекул.

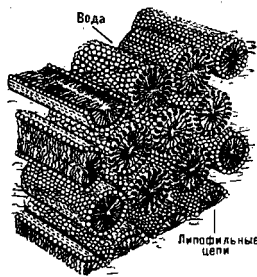


Рис. 11. Схема упаковки молекул в гексагональной фазе лиотропного жидкого кристалла.

Ламеллярные (сметические) фазы образованы дискообразными мицеллами неопределённого диаметра (ламеллами). Толщина ламеллы на 10–30% меньше удвоенной длины амфифильной молекулы (рис. 12), величина водного промежутка между ламеллами изменяется при их набухании. Если данное вещество образует в Р. гексагональные фазы с мицеллами как нормального, так и обратного типов, то ламеллярная фаза располагается на фазовой диаграмме в области концентратив, промежуточных между двумя гексагональными фазами.

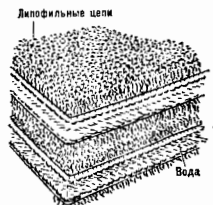


Рис. 12. Схема ламеллярной упаковки амфифильных молекул в воде.

В зависимости от температуры и состава Р. амфифильные молекулы в ламеллах могут находиться в «расплавленном» или «кристаллическом» состоянии. Фаза ламеллярного типа, возникающая при затвердении парафиновых цепей молекул при понижении температуры, носит название фазы геля. Толщина ламеллы в этих фазах может составлять одну или две длины полностью вытянутой амфифильной молекулы. Молекулы упакованы в двумерную гексагональную решётку; площадь, приходящаяся на одну молекулу в бислое, близка к минимально возможной (при одной парафиновой цепи в «жирном хвосте» — ок. 20 \AA^2). Длинные оси молекул могут быть наклонены по отношению к нормали амфифильного слоя. Водный промежуток составляет обычно 10–20 \AA , но может возрастать до $\approx 200 \text{ \AA}$ (т. н. неограниченное набухание), если в системе присутствуют ионогенные амфифильные молекулы, подобные молекулам жирных кислот. Т. о., согласно классификации, принятой для термотропных жидких кристаллов, гели соответствуют сметич. фазам типов V_A и V_C .

При добавлении в систему воды ламеллярные фазы втягивают воду — набухают. При этом возможны два типа набухания. В первом случае весь добавленный растворитель проникает в пространство между полярными «головками» амфифильных молекул, что приводит к увеличению уд. площади, приходящейся на одну молекулу в ламелле. Период ламеллярной структуры остаётся примерно постоянным. Во втором случае при набухании происходит увеличение периода структуры, пропорциональное кол-ву добавленной воды, при пост. уд. площади на молекулу. Возможны также промежуточные типы набухания лиотропных сметич. фаз.

Тип набухания не зависит от длины «жирного хвоста» молекулы в гомологич. ряду данного вещества, а определяется гл. обр. видом её полярной «головки» и «обменным» катионом (ионом щелочного металла, входящим в её состав). Напр., уд. площадь, приходящаяся на полярную «головку» молекулы мыла, при прочих равных условиях возрастает в ряду «обменных» катионов Na^+ , K^+ , Rb^+ , Cs^+ .

Кубические фазы могут возникать при концентрациях Р. промежуточных между концентрациями гексагональной фазы и изотропного мицеллярного Р. либо между концентрациями ламеллярной и гексагональной фаз (рис. 13). Кубич. фазы, обладающие трёхмерной периодичностью, по существу являются не жидкокристаллическими, а относятся к т. н. пластич. кристаллам. Вследствие больших коэф. вязкости ($\eta \approx 10^2$ пуаз) и изотропной оптич. и магн. свойств кубич. фазы нав. также вязкими и изотропными и фазами. Для фаз, расположенных между гексагональной фазой и мицеллярным Р., наиб. вероятно структура с кубич. плотной упаковкой сферич. ми-

целл (рис. 14), а для фаз, расположенных в области концентраций между гексагональной и ламеллярной фазами, предложены т. н. биконтактные структуры, для к-рых поверхность, образованная полярными «головками» амфифильных молекул, делит трёхмерное пространство на две взаимопроницающие области — полярную и гидрофобную. На рис. 15 изображена одна из возможных структур такого типа, поверхность полярных групп для к-рой представляет собой т. н. поверхность Шварца — поверхность, имеющую пост. отрицат. кривизну в каждой точке. Как правило, в биварных системах определённое амфифильное вещество образует лишь некр-ые на перечисленных фаз. В многокомпонентных системах, содержащих кроме амфифильных и др. компоненты, возможно существование не только перечисленных, но и др. фаз (напр., нематических).

Нематические фазы. Нематич. структуры (ор и е в таблице) — оупорядоченны е; см. Дальний и близкий порядок) могут быть образованы мицеллами разл. типов: цилиндрическими, дискообразными или имеющими вид трёхосного аликтоида. В зависимости от типа мицелл различают три типа нематич. структур, два из к-рых являются одноосными, а третий — двухосными. При изменении состава или (и) температуры Р. возможны переходы одного типа нематич. упорядочения в другие. Тензоры диэлектрич. проницаемости ϵ_{ik} и диамагн. восприимчивости χ_{ik} для одноосных нематиков имеют два разл. собств. значения $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ и $\chi_1 \neq \chi_2$ (соответственно показатели преломления обыкновенной и необыкновенной эл.-магн. волн также различаются, см. Анизотропия). Во внеш. магн. поле ось нематиков, образованных цилиндрич. мицеллами, ориентируется параллельно полю, т. е. они имеют положит. анизотропию диамагн. проницаемости: $\chi_a = \chi_1 - \chi_2 > 0$. Анизотропия показателя преломления для этих фаз отрицательна: $n_a = n_1 - n_2 < 0$. Напротив, выделенная ось нематиков, образованных дисками, ориентируется перпендикулярно магн. полю; в этом случае

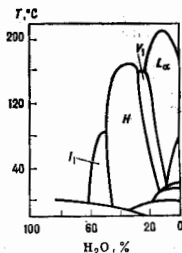


Рис. 13. Фазовая диаграмма раствора хлорида додециламмония в воде. I_1 — кубическая фаза, образованная сферическими мицеллами; H — гексагональная фаза; I_2 — ламеллярная фаза; L_α — ликая изотропная кубическая фаза.

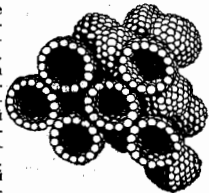


Рис. 14. Схема упаковки сферических мицелл в кубической фазе.

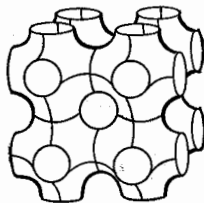


Рис. 15. Регулярная биконтактная структура в виде поверхности Шварца.

перпендикулярно магн. полю; в этом случае

$\chi_a < 0$, $\eta_a > 0$. Знак диамагн. анизотропии определяет анизотропией магн. свойств углеводородных ядер мицелл: разностью восприимчивостей эфирных хвостов вдоль и поперёк оси амфифильной молекулы и степенью упорядочения этих молекул относительно оси мицеллы. В частности, для веществ, молекулы к-рых содержат в составе эфирного хвоста одно или неск. ароматич. колец, знак анизотропии магн. восприимчивости может быть противоположным указанному выше. Знак диалектр. проницаемости нематиков определяется величиной деполяризующего действия мицелл, находящихся в водной среде. По абс. величине значения анизотропии показателя преломления и диамагн. анизотропии, как правило, на 1—2 порядка меньше, чем в случае термотропных нематиков, и составляют $|\eta_a| \approx 10^{-8}$, $|\chi_a| \approx 10^{-8}$.

При изменении направления внеш. магн. поля нематич. структуры переориентируются. Время соответствующего переходного процесса в магн. поле напряжённостью $H \sim 10^4$ Э варьируется в пределах $1-10^2$ с в зависимости от содержания воды в образце. Модули упругости лиотропных нематич. кристаллов на 1—2 порядка меньше, чем в случае термотропных жидких кристаллов: $K = 10^{-7}-10^{-9}$ дин/см². Их величина определяется энергией взаимодействия между мицеллами в Р., к-рая складывается из энергии ван-дер-ваальсовых межмолекулярных взаимодействий и электростатич. энергии взаимодействия ионов, находящихся в Р. и на поверхности мицелл. В нематич. фазах расстояние между мицеллами (цилиндрами и дисками) составляет обычно неск. сотен Å, и искажение структуры растворителя, вызванное присутствием мицелл, по-видимому, слабо сказывается на взаимодействии агрегатов. В нематич. структурах с длиной цилиндрич. мицелл $\sim 10^3$ Å и более существенное значение имеет изгиб мицелл, энергия к-рого сравнима с энергией взаимодействия между мицеллами.

Дефекты и текстуры лиотропных жидких кристаллов. Естественный порядок, существующий в упаковке молекул в мицеллах, а также во взаимном расположении мицелл в Р., определяет особенности текстуры макроскопич. образца. Так, для нематич. лиотропных фаз осн. дефектами упаковки мицелл, к-рые определяют характерную картину изображения образца, получаемую с помощью оптич. поляризац. микроскопа, являются *дисклинизации*. Структура дисклинизаций в лиотропных нематич. кристаллах такая же, как в термотропных.

В ламеллярных фазах наим. энергию имеют деформационные структуры, при к-рых величина водного промежутка постоянна и равна своему равновесному значению по всём объёму образца, за исключением особых линий. Этому условию удовлетворяют краевые *дисклинизации* и различные конвокальные домены, простейшими из к-рых являются мицеллозные фигуры (многослойные структуры, представляющие собой слои, свёрнутые по спирали; рис. 16).

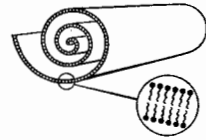


Рис. 16. Схема строения мицелловых фигур.

Краевые дисклинизации, к-рых в лиотропных смектич. жидких кристаллах может быть, по крайней мере, два типа (рис. 17), приводят к образованию т. н. террас Гравяна, видимых в оптический и электронный микроскопы, а также к образованию разл. пучков и сеток.

Структура дефектов в ламеллярных фазах существенно зависит от содержания воды в образце и от темп-ры. Одновременно с изменением текстуры происходит изменение электропроводности Р. и коэф. диффузии ионов. При охлаждении системы в момент образования геля вследствие наклона амфифильных молекул в плоскостях

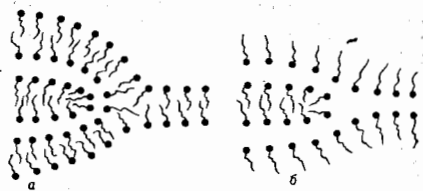
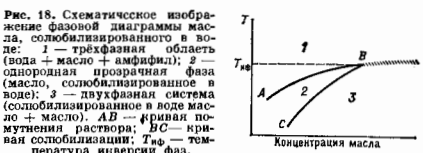


Рис. 17. Два типа краевых дисклинизаций в лиотропных смектич. структурах.

может возникать волнообразная деформация ламелл (наблюдаемая в электронный микроскоп и проявляющаяся в особенностях рассеяния рентг. лучей).

Микроэмульсии

Добавление в систему несмешиваемых в обычных условиях жидкостей (напр., систему масло — вода) амфифильного вещества [а в нек-рых случаях — спирта и (или) неорганич. соли] качественно изменяет свойства системы. Растворимость масла в воде резко возрастает при концентрации амфифильного вещества, превышающей ККМ. Молекулы гидрофобного вещества располагаются в углеводородных ядрах мицелл, размеры к-рых при этом увеличиваются — мицеллы набухают. Такое увеличение растворимости гидрофобных веществ в полярных растворителях (или полярных веществ в жирном растворителе) с образованием агрегатов наз. солюбилизац. е й. Радиус набухших мицелл в нек-рых случаях может достигать неск. сотен Å; мицеллярные Р. при этом наз. микроэмульсиями и типа «масло в воде» (o/w). Способность мицелл набухать в масле обычно ограничена, и при достижении нек-рой критич. концентрации масло отслаивается в виде отд. фазы. На рис. 18 изображён участок фазо-



вой диаграммы солюбилизованного масла; равновесию фазы масла и солюбилизованного в воде масла отвечает кривая солюбилизации BC.

Радиус набухших мицелл определяется площадями, приходящимися на полярную «головку» на поверхности раздела вода — амфифил ($S_{w/2}$) и масло — амфифил ($S_{m/2}$). Для неполярных амфифильных молекул, размеры полярной и гидрофобной частей к-рых примерно равны, предельное значение радиуса кривизны R поверхности масла — вода определяется соотношением

$$R \approx \sqrt{S_{o/w} + \sqrt{S_{w/o}}} L / (\sqrt{S_{w/o}} - \sqrt{S_{o/w}}),$$

где L — полная длина амфифильной молекулы. Величина, стоящая в знаменателе этого выражения, зависит от темп-ры и состава Р., и при нек-рых значениях этих параметров (при темп-ре инверсии фаз) кривизна поверхности мицеллы может менять знак, т. е. происходит обращение микроэмульсии: o/w → w/o («масло в воде» → «вода в масле»). Вблизи темп-ры инверсии фаз мутьность Р. резко возрастает и может наблюдаться, напр., *опалесценция критическая*. В узком интервале темп-ры вблизи темп-ры инверсии фаз (запирхованная область на рис. 18) в Р. обнаруживаются агрегаты разл. формы и состава: цилиндры, одно- и многослойные липосомы,

ламеллы. Наблюдения в оптический и электронный микроскопы, а также данные малоуглового рассеяния рентг. излучения показали, что может возникать своеобразное подобие надмолекулярной организации микромульсий в интервале масштабов от неск. десятков нм до неск. мкм.

Возможность возникновения развитой поверхности масла — вода вблизи темп-ры инверсии фаз связана с резким уменьшением величины *поверхностного натяжения* на этой границе в присутствии амфифильного вещества. Прямые измерения показывают, что добавление амфифильного вещества [а возможно, и спирта и (или) неорганич. соли] может привести практически к полному исчезновению поверхностного натяжения (т. е. ультранизкое поверхностное натяжение).

Коллоидные растворы

К коллоидным растворам, в широком смысле, кроме мицеллярных Р. (наз. также ассоциирующими коллоидами) относят разнообразное суспензии (взвеси) частиц, таких, как белковые глобулы, вирусы (см. *Клеточные структуры*), металлические и полимерные золи и т. п. Частицы в коллоидном Р. взаимодействуют посредством слабых сил: ван-дер-ваальсово притяжение конкурирует с отталкиванием заряженных поверхностей частиц (в условиях акрирования зарядов ионами Р.). В случае гидрофильных частиц (т. е. гидрофильные коллоиды), к к-рым относятся глинистые минералы, а также практически все водорастворимые вещества биол. происхождения, существ. роль играют т. н. гидратац. силы, обуславливающие искажение структуры растворителя вблизи поверхностей частиц (на расстояниях 1—3 нм).

С течением времени частицы, совершающие в коллоидном Р. броуновское движение, слипаются — коагулируют. Скорость этого процесса сильно зависит от величины потенц. барьера на кривой потенц. энергии взаимодействия частиц в Р. (рис. 19), отделяющего

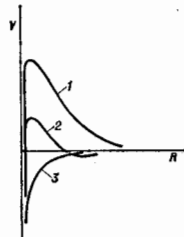


Рис. 19. Потенциальная энергия двух коллоидных частиц, находящихся на расстоянии R друг от друга: 1 — малая концентрация ионов; 2 — концентрация ионов, соответствующая порогу коагуляции; 3 — большая концентрация ионов.

состояние слипшихся частиц от состояния системы до коагуляции. Высота потенц. барьера уменьшается с ростом концентрации ионов Р. и обращается в нуль при нек-рой их критич. концентрации, зависящей от темп-ры, электрич. свойств поверхностей коллоидных частиц и зарядов ионов (кривая 2). При концентрациях ионов, больших критической, имеет место т. н. быстрая коагуляция, при меньших — медленная коагуляция с флуктуаци. преодолением потенц. барьера.

При коагуляции могут возникать как упорядоченные, так и неупорядоченные агрегаты. К первым относятся, напр., тактоиды, образующиеся в Р., содержащих капилсы вируса табачной мозаики, и по существу представляющие собой нематические фазы литротических жидких кристаллов. Упорядоченные кубические кристаллы возникают в Р., содержащих полимерные частицы (напр., шарики латекса диаметром 100—1000 нм). К неупорядоченным агрегатам относятся т. н. гели, к-рые образуются в коллоидных Р. разл. состава и представляют собой упрочие твёрдые тела, имеющие трёхмерный кар-

кас из слипшихся коллоидных частиц — цилиндров, пластинок и т. п. Пустоты в каркасе заволашеваются растворителем. Полимерные гели образуются макромолекулами, скрещёнными между собой к-л. хим. звеньями (напр., резина, набухшая в бензине, представляет собой Р. нитей каучука, «сшитых» в нек-рых точках серыми мостиками). Содержание растворителя в теле может увеличиваться (набухание) или уменьшаться (осушение) при изменении темп-ры или (или) ионной силы Р. Как правило, набухание гелей ограничено, а изотоп жидкости отслаивается в отд. фазу.

Модуль упругости геля зависит от концентрации «сшивок» между отд. частями (рис. 20), причём конечный

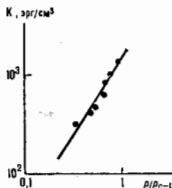


Рис. 20. Зависимость модуля упругости K геля от концентрации «сшивок» между полимерными модулями (по оси абсцисс — параметр надкритичности $(p/p_c - 1)$, где p — концентрация «сшивки», p_c — её критич. значение).

модуль сдвига появляется при нек-рой критич. концентрации «сшивок». Процесс образования геля из жидкого коллоида наз. фазовым переходом типа — гель.

Коллоидные Р. глинистых минералов, подобных монтмориллониту, обладают свойством тиксотропии, а именно: при механич. размешивании Р. представляет собой жидкость, а в состоянии покоя — гель. Трёхмерный каркас монтмориллонитовых гелей образован кристаллич. аломосиликатными пластинками (диаметром в неск. сотен нм, толщиной ок. 1 нм), несущими заряды — отрицательные на поверхностях и положительные на торцах. В геле соседние пластинки могут быть ориентированы как параллельно друг другу (т. н. плотные контакты; в этом случае расстояние между ними определяется балансом электростатических, ван-дер-ваальсовых и гидратацонных сил; рис. 21), так и пер-

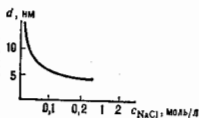


Рис. 21. Зависимость расстояния d между параллельными аломосиликатными пластинками монтмориллонита от концентрации NaCl .

пендикулярно друг другу. В зависимости от содержания воды и разл. солей (глинистые минералы обладают свойством избират. связывания ионов из раствора, напр. ионов K^+ , Cs^+ , Ca^{++} , Sr^{++} и др.) относят долю контактов двух типов изменяется, а с ней изменяются и реологич. свойства гелей.

Особенность мн. коллоидных Р. — наличие звучит. времён релаксации неравновесных состояний: даже в сравнительно равновесных суспензиях релаксац. процессы могут длиться неделями и месяцами.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., М., 1976; Курс физической химии, 2 изд., т. 1, М., 1968; Сивухин Д. В., Общий курс физики, 2 изд., т. 2 — Термодинамика и молекулярная физика, М., 1979; Веденов А. А., Ливчицкий Е. В., Надмолекулярные индикристаллические структуры в растворах амфифильных молекул, «УФН», 1983, т. 141, с. 3; Веденов А. А., Физика растворов, М., 1984; Микромульсии. Структура и динамика, под ред. С. В. Фрибурга, Л. Вотореза, пер. с англ., М., 1990. А. А. Веденов, Е. В. Ливчицкий. РАСТР (от лат. *rastrum* — грабли) — решётка, обычно служащая для пространственного структурного преобразования проходящего через неё или отражённого ею направленного пучка лучей. Решётчатые структуры, взаимодействующие не со световыми, а с др. рода излу-

ниями, соответственно наз. рентг., акустическими и др. Р. Изображение, промодулированное Р., наз. растровым изображением, а сам процесс получения такого изображения наз. растриванием.

Решётки оптич. Р. формируются из большого числа односторонних элементов (отверстий, линз, призм, зеркал и др.), определённым образом расположенных на к.-л. поверхности — плоской, цилиндрич., сферич. и др. формы. В зависимости от вида элементов Р. подразделяются на щелевые, линзовые, призматич., зеркальные и т. д. Геом. структура решёток, образующих Р., разнообразна.

Нек-рые типы плоских Р. см. на рис. 1. Если элементы Р. представляют собой ряд параллельных линий, то Р. наз. линейным (а), если элементы расходятся в виде лучей из одного общего центра, Р. наз. радиальным (б), если элементы выполнены в виде концентрич. колец, — кольцевым (в). Элементы Р. в виде ячеек могут быть образованы пересечением линейных Р. (д). При пересечении двух систем параллельных линий (линятуры)

(дискретизируется). На близком расстоянии от Р. распространение такого дискретизованного пучка подчиняется преобразованию по законам геом. оптики. Однако на значит. расстоянии от Р. дифракц. явления и интерференция изменяют пространственную структуру дискретизованного пучка. Регулярные Р. на больших расстояниях работают как дифракционные решётки. В связи с этим различают контактные Р., проекционные и растры — дифракц. решётки.

При контактом наложения двух Р. с периодич. структурами образуются комбинац. полосы муара (рис. 2), повторяющиеся в увелич. масштабе структуры совмещаемых Р. Интервал сдвигания комбинац. полос зависит от периодов Р. a_1 и a_2 и угла φ между направлениями их линятуры соответственно:

$$w = a_1 a_2 \left(\frac{a_1^2 + a_2^2}{a_1^2 a_2^2} - 2a_1 a_2 \cos \varphi \right)^{-1/2}.$$

Образование муара применяется в технике для контроля очень малых угл. и линейных перемещений. Р. используются для получения цветных телевиз. изображений, для изготовления стереоскопич. фотографий, для печати типографским способом полутоновых изображений, для получения контрастных рентг. изображений и для решения др. оптич. задач. В полиграфии оптич. полутоновое изображение разбивается Р. на отд. дискретные элементы. Изображение, состоящее из таких элементов, позволяет передавать градиенты яркости полутонового изображения с помощью элементов одинаковой светлоты, но различной величины. Сопряжение Р. с краями или др. Р. образует растровые оптич.

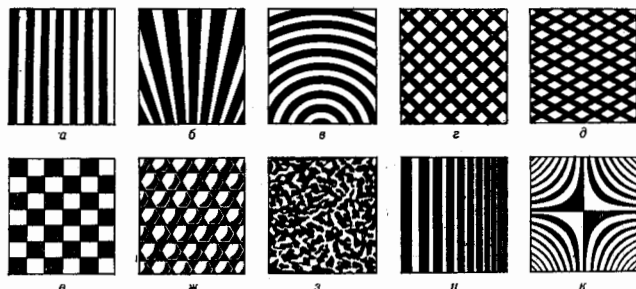


Рис. 1.

под углом 90° образуется Р. ортогональной структуры (е); элементы Р. могут располагаться в шахматном порядке (г) и др. разл. образом. Р., составленные из шестиугольных элементов (в виде сот), наз. гексагональными (ж). Элементы Р. могут представлять собой хаотически распределённые ячейки неправильной формы; такой зернистый Р., применяемый в полиграфии, наз. норковым (з). Распределение элементов в плоскости Р. может подчиняться разл. закономерностям в зависимости от назначения Р. Так, распределение элементов одномерного Р. Жирара (и), применяемого в спектромонометрах, описывается косинусoidal. ф-цией $\cos^2 x$, более сложное распределение гиперболич. двумерного Р. Жирара показано на рис. 1, к.

Существуют Р., элементы к-рых не имеют чётких границ; напр., прозрачный участок постепенно переходит в непрозрачный — такие Р. наз. полупрозрачными. Если в пределах прозрачного участка элемента Р. постепенно изменяется показатель преломления среды, то Р. наз. фазовым. Элементы Р. могут группироваться для выделения опред. участка спектра и определенного типа поляризации; такие Р. наз. соответственно цветными и поляризационными.

Осн. геом. характеристики Р.: форма поверхности, тип составляющих его элементов, структура и распределение элементов по поверхности. Осн. оптич. характеристики Р.: период, связность, геом. форма и размеры его элементов.

Оптич. эффект действия Р. зависит от типа и условий использования. Пучок света, прошедший через Р. (или отражённый им), разбивается на отд. дискретные пучки

ческие системы, обладающие рядом особых оптич. свойств.

Лит. см. при ст. Растровые оптические системы. Н. А. Волос.

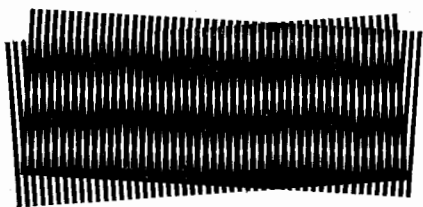


Рис. 2.

РАСТРОВАЯ ОПТИКА — область оптики, рассматривающая законы формирования и преобразования дискретизованных растровыми оптическими системами изображений, содержащих многомерную информацию.

РАСТРОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ — класс оптич. систем, составным элементом к-рых является растр. Наличие раstra образует в системе множество входных и выходных зрачков, смежно расположенных и действующих совместно в формировании оптич. изображения. Такие системы обладают рядом специфич. свойств, как множачее, интегрирующее, анализирующее.

Простейшую Р. о. с. представляет комбинация раstra R и установленного на нем диффузно отражающего экрана E (рис. 1). Элементы раstra — отверстия или линзы — создают на экране множество более или менее совершенных изображений объекта. Это — первичное множачее свойство Р. о. с. Обратный ход лучей от изображений, полученных на экране,

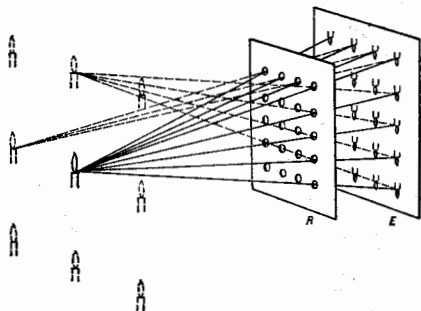


Рис. 1. Простейшая растровая оптическая система: R — растр, E — экран.

восстанавливает естеств. форму объекта в предметном пространстве. Синтезирование целостного пространственного образа объекта лучами от каждого элементарного изображения представляет интегрирующее свойство Р. о. с. В предметном пространстве восстанавливается не одно изображение, а множество ему подобных — это вторичное множачее свойство Р. о. с.

Осн. свойства Р. о. с. наиб. полно проявляются при формировании пространственных изображений в интегральной фотографии, являющейся как бы лучевым аналогом голографии. На первой стадии получают интегральное изображение объекта AB (рис. 2) через

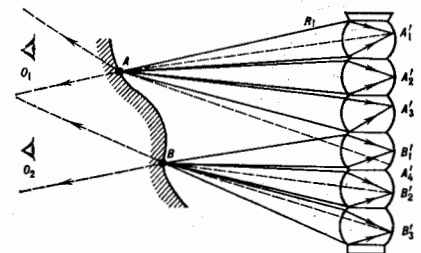


Рис. 2. Получение интегрального изображения объекта AB с помощью ячеистого раstra R_1 .

ячеистый (лиазовый) растр R_1 , элементы к-рого выполнены в виде цилиндров с передними сферич. основаниями, фокусирующими изображения объекта на противоположных сторонах этих цилиндров, покрытых с наружной стороны фотоэмульсией. При съемке на слое фотоэмульсии образуется большое число микроизображений объекта в виде матрицы, наз. аспектrogramмой. Эти изображения A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 и т. д. не совсем идентичны, они фиксируют объект с несколь-

ко разных точек зрения и поэтому различаются параллактич. сдвигами разноудаленных точек объекта. Если осветить полученную на растре матрицу изображений с тыльной стороны, то обратный ход лучей через линзы раstra воссоздаст действительное изображение трёхмерного объекта в предметном пространстве. Разноудаленные точки объекта AB можно увидеть на продолжении лучей от точек A, B из положений O_1, O_2 и т. д. Однако наблюдаемая пространственная картина объекта при этом оказывается инвертной (с вывернутым рельефом) — выступающие детали объекта углублены, и наоборот. Получение правильного рельефа пространственного изображения осуществляется во второй стадии процесса оптич. переносирования микроизображений аспектrogramмы через линзы первого раstra R_1 на аналогичный второй растр R_2 , как это показано в верх. части рис. 3. За линзами раstra R_2

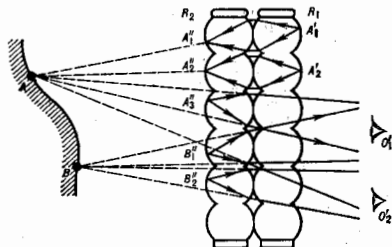


Рис. 3. Оптическое переносирование микроизображений аспектrogramмы.

получается обращенная аспектrogramма с микроизображениями $A_1'B_1', A_2'B_2', \dots$, рассматривая к-рую через этот растр после удаления от него раstra R_1 , как это показано на ниж. части рис. 3, можно увидеть из точек O_1, O_2, \dots мнимое пространственное изображение объекта AB с уже правильно восстановленным рельефом. Ячеистый растр здесь применяется для раграничения полей микроизображений, регистрируемых на аспектrogramме.

Разделение полей микроизображений во время записи (съемки) аспектrogramмы можно осуществлять также с помощью полевой диафрагмы, ограничивающей поле зрения растровой системы в предметном пространстве. Такой диафрагмой может являться входной зрачок объектива, работающего совместно с Р. о. с. Рис. 4 иллюстрирует принцип работы Р. о. с. при записи многомерной информации об объекте AB через раал. участ-

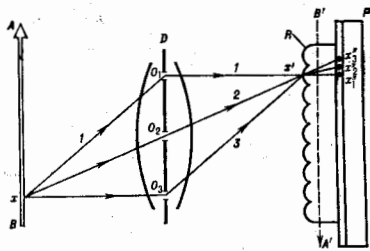


Рис. 4. Растровая оптическая система с анаэно аспектrogramмы объекта AB с помощью полевой диафрагмы.

ки входного зрачка съёмочного объектива. Когда открыт небольшой участок O_1 входного зрачка объектива, лучи от объекта AB , проходящие этот участок, рисуют изображение объекта $A'B'$ так же, как и при полном открытом зрачке, однако, проходя через элементы раstra, они засвечивают не всю поверхность светочувствительного слоя фотопластины P , а только отд. точки на ней. Так, луч 1 от точки x объекта, создавший изображение x' , фиксируется на светочувствит. слое в точке x'_1 . Если же будут открыты участки зрачка O_2 или O_3 , то лучи от точки x объекта, создавая ту же точку изображения x' , зафиксируются в светочувствит. слое соответственно в точках x'' и x''' . Т. о., при перемещении открытого участка зрачка на фотогр. материале фиксируется ряд последоват. кадров изображения объекта. Это позволяет осуществлять фоторегистрацию (киносъёмку) движущихся объектов или совмещать на одной и той же фотопластине разнородные изображения, различно фотографируемые при разл. местоположениях открытого участка в зрачке. Выборка каждого отд. изображения из полученного на фотоматериале смешанного интегрированного кадра возможна после проявления фотопластины, установки её в прежнее положение и освещения со стороны ахатного зрачка через те участки, к-рые были открыты при фотогр. записи изображений. Возможное число раздельно различных изображений в смешанном кадре наз. ёмкостью $P. o. c.$; в совр. растрах эта величина доходит до 1000.

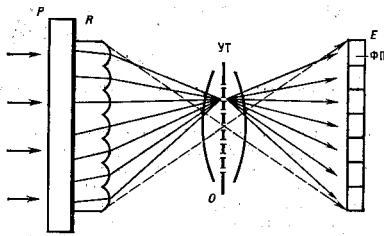


Рис. 5. Принципиальная схема для параллельной обработки многомерной информации: K — растр; P — фотопластина; УТ — управляемый транспарант; O — объектив; E — экран; ФП — фотоприёмник.

В сочетании с управляемыми транспарантами и матричными твердотельными фотоприёмниками $P. o. c.$ дают возможность производить равнообразную параллельную обработку массивов многомерной информации (рис. 5). Ряд страниц информации, последовательно записанных через растр на пластинке P , воспроизводится через тот же растр R объективом O на экране E , выполненном, напр., в виде матрицы фотоприёмников. Если при этом во входном зрачке объектива находится управляемый транспарант УТ, с помощью к-рого можно делать прозрачными разл. участки зрачка, то, открывая эти участки, можно в разл. порядке процировать записанные страницы на экран для считывания. Можно одновременно процировать неск. страниц информации на экран, если одновременно открыто неск. светлых клапанов транспаранта; модулируя соответствующим образом светопропускание транспаранта, можно задавать режимы обработки информации (сложение, вычитание и т. п.).

Принцип действия $P. o. c.$ применим и к электронным, рентг. и др. пучкам лучей. На рис. 6 представлено схема электронной растровой системы, используемой для формирования цветного изображения на экране телевиз. трубки. Пучки электронов от электронных пушек K_1, K_2, K_3 проходят через щели раstra R_1 ;

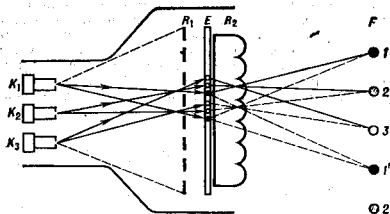


Рис. 6. Схема электронной растровой системы.

пространственно разделяясь, попадают на участки экрана с люминофорами соответственно красного, зелёного и синего свечения. Аддитивно смешиваясь, эти свечения образуют на нек-ром расстоянии второе изображение. Если перед экраном установить второй растр R_2 , то он пространственно разделит пучки лучей, исходящих от разных по цвету элементов экрана, создавая зоны в точках 1, 2, 3, а также в точках 1', 2', 3' и т. д., из к-рых можно видеть, соответственно, только красное, зелёное или синее изображение. Если же пучками K_1, K_2, K_3 процировать на экран не цветные, а стереоскопические изображения, то из точек 1, 2, 3 и т. д. можно будет видеть соответственно разл. ракурсы пространственного изображения и т. о. наблюдать на экране объёмное изображение.

Др. равнообразные структуры $P. o. c.$ позволяют осуществлять фокусирование, дефлектирование, спектральную и селективную фильтрацию световых пучков и т. п. Интересной особенностью $P. o. c.$ является то, что при записи дискретизованных изображений через линзовый растр со щелевой решёткой в его фокальной плоскости (рис. 7) можно получать

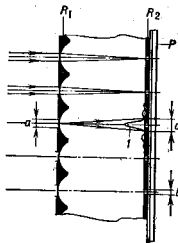


Рис. 7. Дифракция на входной апертуре дифрагмированного линзового раstra R_1 с линзой диаметром d . R_2 — щелевой растр со щелью b ; F — фотопластина; a — кривая дифракционного рассеяния; I — распределение интенсивности дифракционного рассеяния в фокальной плоскости линзового раstra.

более высокое разрешение, чем это следует из дифракц. теории, за счёт пропускания через механич. щели только центр. части дифракц. картины (диска Эйри), а это позволяет получать большие плотности записи оптич. информация на перемещаемом фотоматериале.

Лит.: В а л о у Н. А., Растровая оптика, М.—Л., 1949; с т о ж е, Растровые оптические приборы, М., 1966; Д у д н и к о в Ю. А., Р о ж и к о в Б. К., Растровые системы для получения объёмных изображений, Л., 1986. Н. А. В а л о у, РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП — см. Электронный микроскоп.

РАСТЯЖЕНИЕ (сжатие) — 1) одноосное растяжение и сжатие) — простейшая деформация, возникающая в призматич. бруске, подверженном равномерному растяжению или сжатию. Такая деформация возникает вдали от концов бруса, к торцам к-рого приложена система сил, приводящая к силе F , направленной вдоль осей центров тяжести поперечного сечения бруса. При F поперечные сечения остаются плоскими, а

нормальные напряжения σ в поперечном сечении распределены равномерно и равны $\sigma = F/S$, где S — площадь поперечного сечения. Удлинение Δl бруса длиной l при упругих деформациях определяется ф-лой $\Delta l = Fl/ES$, где ES — жесткость при P , E — модуль упругости. При удлинении бруса его поперечное сечение уменьшается. Отношение относительного уменьшения поперечного сечения — ν к относительному удлинению ϵ упругого бруса численно равно коэффициенту Пуассона ν . Зависимость между σ и ϵ сложна механич. характеристикой материала; она находится из опытов на испытат. машинах. В пределах линейной упругости $\sigma = E\epsilon$. Если σ больше предела текучести σ_0 , зависимость между σ и ϵ более сложная (см. Пластичность).

2) Всестороннее равномерное растяжение (сжатие) — напряженно-деформированное состояние, возникающее в теле под всесторонним равномерным давлением P . При этом во всех точках тела все направления будут главными, а сами напряжения равны P . И. В. Кеннеди.

РАСХОДИМОСТИ и квантовой теории поля — бесконечности, появляющиеся в разложении величин квантовой теории поля в ряд теории возмущений при интегрировании по 4-импульсам виртуальных частиц. В *Фейнмановых диаграммах* такому интегрированию отвечают замкнутые петли. Соответствующие интегралы могут расходиться как в области больших, так и в области малых импульсов (когда в теории имеются частицы с нулевой массой покоя). В соответствии с этим различают *ультрафиолетовые расходимости* и *инфракрасные расходимости*.

Ультрафиолетовые P . в перенормируемой теории (см. *Перенормируемость*) после *регуляризации расходимостей* устраняются методом *перенормировки*. Инфракрасные P . процессов с конечным числом частиц компенсируются в *инклюзивных сечениях* (см. *Инклюзивный процесс*), учитывающих дополнит. испускание частиц нулевой массы (напр., фотонов), не регистрируемых установкой из-за её ограниченного разрешения по энергии. А. В. Ефремов.

РАУЛЯ ЗАКОН — зависимость относительного понижения давления парциального пара растворителя от концентрации растворенности вещества. Установлен Ф. Раулем (F. Raoult, 1886) для разбавленных растворов. Согласно $P_{i1} = p_1 \cdot n_1 / (n_1 + n_2)$,

$$(p_1 - p) / p_1 = n_2 / (n_1 + n_2),$$

где p и p_1 — давление насыщенного пара растворителя над раствором и чистым растворителем соответственно, n_1 и n_2 — числа молей растворенного вещества и растворителя (при расчёте молей нужно учесть состояние молекул раствора — диссоциацию, ассоциацию молекул или сохранение их в индивидуальном, целостном виде).

P . з. всегда справедлив для бесконечно разбавленных растворов, т. е. при $n_2 \rightarrow 0$; в этом случае его можно записать в виде

$$(p_1 - p) / p_1 = n_2 / n_1 = N_2,$$

где N_2 — молярная доля растворенного вещества в растворе. Для идеальных растворов P . з. применим при любых концентрациях растворенного вещества и задписывается в виде

$$p = p_1 N_1,$$

где N_1 — молярная доля растворителя в растворе.

См. также *Растворы*.

РАУСА УРАВНЕНИЯ — дифференц. ур-ния движения механич. системы в переменных Рауса. Предложены Э. Раусом (E. Routh) в 1867. Для системы с s степенями свободы, находящейся под действием потенц. сил, P . у. имеют вид

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial R}{\partial q_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, m; m < s), \quad (1)$$

$$\frac{d^2 p_k}{dt^2} = \frac{\partial R}{\partial p_k}, \quad \frac{d^2 p_k}{dt^2} = - \frac{\partial R}{\partial q_k} \quad (k=m+1, \dots, s). \quad (2)$$

где $R(q_i, p_k, q_i, q_k, t) = \text{Рауса функция}$, q_i, q_k — обобщенные координаты системы, \dot{q}_i — обобщенные скорости, p_k — обобщенные импульсы, t — время. Формально равенства (1) и (2) имеют соответственно вид ур-ний Лагранжа (где R играет роль ф-ции Лагранжа L) и ур-ний Гамильтона (где R играет роль ф-ции Гамильтона H).

P . у. удобно использовать, когда часть координат системы является *циклическими координатами*. Пусть q_k — циклич. координаты, тогда они в выражении R явно не входят. Следовательно, $\partial R / \partial q_k = 0$ и, согласно второй совокупности ур-ний (2), $p_k = \alpha_k$, где α_k — постоянные интегрирования. В результате $R = R(q_i, q_i, \alpha_k, t)$ и ур-ния (1), как и обычные ур-ния Лагранжа, дадут систему m дифференц. ур-ний 2-го порядка относительно обобщенных координат q_i . Т. о., число дифференц. ур-ний, к-рые надо проинтегрировать для нахождения закона движения системы, уменьшится на число циклич. координат. Если это интегрирование будет осуществлено, то q_i определяется в виде $q_i(t, c_1, c_1')$, где c_1, c_1' — новые постоянные интегрирования. После этого можно вычислить R в виде $R(t, c_1, c_1', \alpha_k)$ и остальные (циклич.) координаты найдутся из первой группы ур-ний (2) с помощью квадратур:

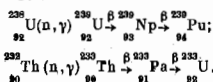
$$q_k = \int (\partial R / \partial \alpha_k) dt.$$

Лит.: 1) Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике, М., 1960, § 13, 14; 2) Голдштейн Г., Классическая механика, пер. с англ., 2 изд., М., 1975, § 7, 2; 3) Лурье А. И., Аналитическая механика, М., 1961, § 7, 16, § 7, 17 (соответст. P . у. для случая велосциальных сил); С. М. Тара, **РАУСА ФУНКЦИЯ** — характеристич. ф-ция механич. системы, выраженная через переменные Рауса, к-рым являются время t , все s обобщенных координат q_i системы, обобщенные скорости \dot{q}_i , соответствующие к-ным-то m из этих координат, и обобщенные импульсы p_k , соответствующие остальным $s-m$ координатам. Такой выбор переменных удобен, когда $s-m$ координат q_k являются циклич. координатами. Если *Лагранжа функция* $L(q_i, \dot{q}_i)$ для данной системы известна, то P . ф. определяется из равенства

$$R(t, q_i, q_k, \dot{q}_i, p_k) = \sum_{k=m+1}^s p_k \dot{q}_k - L,$$

в правой части к-рого все \dot{q}_k ($k=m+1, \dots, s$) следует выразить через p_k , используя соотношения $p_k = \partial L / \partial \dot{q}_k$. Когда координаты q_k являются циклическими, они в P . ф. не входят: при этом одновременно $p_k = \text{const} = \alpha_k$ при $R = R(t, q_i, \dot{q}_i, \alpha_k)$. См. также *Рауса уравнения*. С. М. Тара.

РЕАКТОР-РАЗМОЖИТЕЛЬ (бридер) — ядерный реактор, особенностью к-рого является способность к расширенному воспроизводству (рамножению) делющихся ядер (*ядерного горючего*). Воспроизводство ядерного горючего в реакторах осуществляется за счёт поглощения части нейтронов в реакторе т. н. ядерным сырьём ^{238}U , ^{232}Th (*радиационный захват нейтронов*) и образованием при этом искусств. ядерного горючего — ядер ^{239}Pu , ^{233}U :



Проблема воспроизводства важна для энергетических реакторов, в первую очередь для атомных электростанций (АЭС). Наиб. важен уран-плутониевый цикл, в к-ром сырьем служит ^{238}U , а выгорает и вновь образуется ^{239}Pu . Если в реакторе используется уран, обогащенный изотопом ^{235}U , то вместо выгорающего ^{235}U образуется ^{239}Pu . Такой т. н. конверсионный цикл может служить лишь нач. стадией перехода к основному уран-плутониевому циклу в Р-р.

Коэф. воспроизводства K наз. отношение кол-ва вновь образовавшегося горючего к кол-ву выгоревшего за то же время. Расширенное воспроизводство имеет место, когда $K > 1$. В уран-плутониевом цикле кроме ^{239}Pu образуются, как следуют, погашения нейтронов ядра ^{240}Pu , ^{241}Pu , ^{242}Pu . Эти ядра также претерпевают деление, размножат нейтроны и могут вносить вклад в мощность Р-р. После неск. лет работы в Р-р. устанавливается постоянный (асимптотич.) состав основных делящихся ядер (не зависящий от исходного), в к-ром содержится 65—75% ^{239}Pu , остальное приходится на вышележащие изотопы. Постоянство состава делает возможным и целесообразным определение коэф. воспроизводства K для такого ядерного горючего.

Величина K определяется относит. кол-вом нейтронов, поглощающихся в ядерном сырье. Это кол-во зависит от ядерных свойств всех материалов, находящихся в реакторе. Оно обусловлено необходимостью обеспечить протекание ядерной цепной реакции деления.

Формула баланса имеет вид

$$K = \nu - \alpha - 1 + (\nu_2 - 1)\epsilon - \delta. \quad (1)$$

Здесь $\bar{\nu}$ — ср. кол-во вторичных нейтронов, приходящихся на один акт деления ядра Pu (усредненное по всем 4 его изотопам со статич. весом, пропорциональным вероятности их деления); α — отношение сечения радиаци. захвата нейтрона к сечению деления Pu (с тем же усреднением); ν_2 — ср. кол-во вторичных нейтронов на 1 акт деления ядра ^{238}U ; ϵ — доля актов деления ядер ^{238}U на один акт деления Pu ; δ — потери нейтронов в результате захвата в неделящихся материалах и утечки наружу на один акт деления Pu . Существуют и др. способы определения K , относящиеся только к ^{239}Pu и по-разному учитывающие взаимодействие нейтронов с материалами.

Величина K зависит от энергии нейтронов. С увеличением энергии от тепловой области к быстрой уменьшаются α и δ и растёт ϵ . В результате, если для реакторов на тепловых нейтронах для ^{239}Pu $K < 1$, то для реакторов на быстрых нейтронах $K > 1$ ($K = 1, 2 - 1,6$). Т. о., в быстрых реакторах имеет место расширенное воспроизводство ^{239}Pu . Терм. быстрый реактор по существу — синоним Р-р.

Расширенное воспроизводство ^{233}U с K , немного превышающим 1, возможно и в тепловых реакторах. Для получения необходимого кол-ва ^{233}U реактор должен начать работу на ^{235}U или ^{239}Pu .

Устройство и особенности. В тепловыделяющих элементах (ТВЭЛх) Р-р. в качестве топлива обычно используется керамика, смесь $\text{PuO}_2 - \text{UO}_2$, иногда др. прочие хим. соединения или смесь Pu и U в виде металлов. Оболочкой ТВЭЛа служит тонкостенная трубка diam. 6—8 мм. В цилиндр, активной зоне (объем неск. м³) размещаются (2—5) · 10⁴ ТВЭЛов. Группы ТВЭЛов (100—200) собираются в т. н. тепловыделяющие сборки (ТВС). Быстрые нейтроны обладают большой проникающей способностью, и поэтому заметное их кол-во покидает активную зону. Для утилизации этих нейтронов в отражателе реактора помещается ^{238}U (UO_2), в к-ром, как и в активной зоне, происходит накопление Pu . Такой отражатель наз. экранирующим или blanketом.

В Р-р. отсутствуют вещества-замедлители нейтронов (упругое рассеяние). Однако некое замедление нейтронов всё же происходит за счёт г. обр. неупругого рассеяния. Поэтому энергетич. спектр нейт-

ронов несколько мягче спектра нейтронного деления (неск. сотен кэВ вместо 2 МэВ).

Особенности Р-р. определяются взаимодействием быстрых нейтронов с материалами активной зоны. Сечения деления для быстрых нейтронов существенно ниже (на 2 порядка), чем для тепловых. В результате критическая масса значительно больше, чем для тепловых реакторов (в тех же размерах). Чтобы снизить уд. затраты на ядерное горючее, «заомороженное» в критич. массе, необходимы высокие плотности теплового выделения (~1000 кВт/л). Для столь интенсивного отвода тепла из реактора в качестве теплоносителя применяется жидкий Na (вода исключается, т. к. является замедлителем нейтронов). Недостаток Na — высокая хим. активность при взаимодействии с водой или кислородом воздуха, что может негативно проявляться при аварийных ситуациях.

Отношение сечения деления Pu к сечению радиаци. захвата ^{238}U для быстрых нейтронов намного меньше, чем для тепловых. Поэтому для обеспечения критич. режима необходимо увеличивать концентрацию Pu в смеси $\text{Pu} - \text{U}$ до 16—30% (в тепловых ~ 2—3%). Время жизни нейтронов в Р-р. (время между двумя последоват. циклами деления) порядка 10⁻⁷—10⁻⁸ с (в тепловых реакторах на неск. порядков больше).

Особенностью Р-р. является трехконтурная схема: На первичного контура передает тепло из реакто-

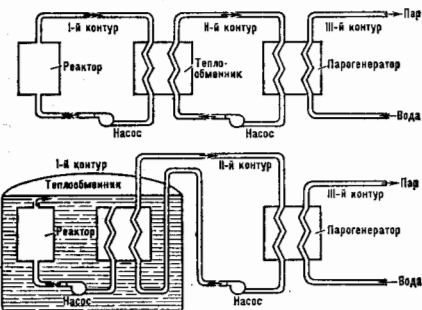


Рис. 1. Петлевая (а) и интегральная (б) схемы размещения оборудования.

ра в теплообменнике натрия второго контура. Последний же и парогенератор нагревает воду третьего контура, к-рая испаряется в пар и поступает на турбину. При этом исключается опасность попадания воды в активную зону, что может вызвать нежелат. изменение реактивности. Исключается также возможность взаимодействия воды с радиоактивным Na (первичного контура) с последующим выходом радиоактивности наружу.

Существуют 2 варианта компоновки АЭС: петлевой и интегральной (рис. 1). В петлевом варианте все натриевые контуры размещаются в изолир. боксах, заполненных воздухом или инертным газом. В интегральном варианте все элементы первичного контура (насосы, теплообменники, трубопроводы и сам реактор) помещаются в бак, заполненный Na , к-рый также участвует в циркуляции по первичному контуру.

Первый отечеств. пром. Р-р. БН-350 (АЭС в г. Шевченко) двухцелевого назначения (энергетика и опреснение морской воды) тепловой мощностью 750 МВт выполнен в петлевом варианте; реактор БН-600 (Свердловская обл.) электрич. мощностью 600 МВт имеет интегральную компоновку. Пром. Р-р. работают также во Франции и Великобритании. Сооружается отеч-

ственный Р.-р. мощностью 800 МВт (БН-800); его характеристики см. в табл.

Характеристики БН-800

Мощность электрическая, МВт	800
Тип цикла, %	40
Температура Na на выходе из реактора, °C	550
Температура пара, °C	490
Давление пара, МПа	14
Размер бака первичного контура (диаметр/высота), м	13/13
Размер активной зоны (диаметр/высота), м	2,5/1
Топливо, МПа, УО,	РиО ₂ -УО,
Критическая масса Ри, т	2,5
К	1,3

Топливный цикл. Глубина выгорания топлива (отложение кол-ва выгоревшего топлива к нач. кол-ву Ри и U в ТВЭЛ) и соответственно длительность работы ТВС (тепловыделяющей системы) на номинальной мощности ограничены неск. факторами: опасностью выхода из строя ТВЭЛов в результате коррозии, воздействия на оболочку накапливаемых продуктов деления; угрозы недопустимой деформации ТВС при длит. воздействии интенсивных потоков быстрых нейтронов (т. е. вакуационное распухание стали); повышением давления внутри ТВЭЛ из-за накопления газообразных осколков.

Достижимая ср. глубина выгорания в БН-800 порядка 4%. Это соответствует длительности (кампания) ~ 1,5 лет. Отработавшие ТВС извлекаются для регенерации и последующего воаравнения топлива в реактор. Схема круговорота топлива (топливного цикла) представлена на рис. 2. Выдержку отработавшего топлива (в спец. хранилищах) требуется для спада радиоактивности (и соответственно тепловыделения) до уровня, при к-ром не возникает особых затруднений при регенерации. Время выдержки ≥ 3 лет.

Регенерация состоит из хим. переработки, при к-рой происходит очистка от осколков, и изготовления ТВС. Несмотря на предварит. выдержку, радиоактивность топлива остается высокой, что требует дистанц. произ-



Рис. 2. Топливный цикл.

водства в хорошо защищенных (тяжелых) боксах или кюветах. Изготовление ТВС также дистанционно из-за токсичности Ри, заметной γ-активности ²⁴¹Pu и др. выш. изотопов и частично из-за нейтронной активности. Образующийся илльшек горючего направляется в новые ТР.-р.

Темп воспроизводства ядерного горючего λ приблизительно равен отношению кол-ва выработанного за 1 год в реакторе излишка горючего к его общему кол-ву, запитанному во всем топливном цикле. Он определяется ф-лой

$$\lambda = 384(K^* - 1) / M_a \left(\frac{1}{\phi} + \frac{t_b}{t_a} \right) (t + \varepsilon).$$

Здесь K^* — техн. коэф. воспроизводства, учитывающий технол. потери горючего, а также потери нейтронов, связанные с захватом осколками; M_a — уд. критич. нагрузка горючего (кг), отнесенная к тепловой мощности реактора 1000 МВт; ϕ — коэф. нагрузки реактора; t_a и t_b — длительности работы ТВС и внешнего цикла. Иногда вместо λ для характеристики роста мощности употребляется т. п. время удвоения, равное $0,7/\lambda$; для оксидов $\lambda \approx 2,5\%$, для металлов $\lambda \approx 5,0\%$.

Значение и перспективы. Р.-р. позволяют использовать в качестве ядерного горючего (путем превращения U в Ри) практически весь добываемый уран. Тем самым сырьевая база ядерной энергетики увеличивается, по крайней мере, в неск. десятков раз. В Р.-р. может

быть полностью использован и Th, превращенный в ²³³U. В техн. и технол. плане Р.-р. разработаны достаточно хорошо. В экономич. отношении они пока уступают тепловым реакторам. Топливная составляющая стоимости электроэнергии для Р.-р. зависит от затрат на регенерацию топлива. Для тепловых реакторов эта стоимость определяется затратами на добычу природного урана. Однако в дальнейшем, в связи с увеличением затрат на добычу урана (по мере истощения осн. месторождений), совершенствованием и упрощением конструкции Р.-р., станут более предпочтительными.

Лит.: Дьячкова К. А., И. Состояние и перспективы развития быстрых реакторов, «Атом. энергия», 1970, т. 28, в. 4, с. 297; Усманов Г. В., Кусимарев Е. В., Реакторы с быстрыми нейтронами, М., 1965; Казачиновский О. Д., Реакторы на быстрых нейтронах — взгляд в будущее, «Атом. энергия», 1987, т. 63, в. 5, с. 239. О. Д. Казачиновский.

РЕАКЦИИ СВЯЗЕЙ — для связей, реализуемых с помощью к.-в. тел (см. *Связи механические*), — силы, с к-рыми эти связи действуют на тела механич. системы, препятствуя тем или иным их перемещениям в пространстве. В отличие от активных сил, Р. с. являются величинами заранее неизвестными; они зависят от вида связей, от значений действующих на систему активных сил, а при движении системы ещё и от закона её движения и определяются в результате решения соответствующих задач механики. Направление Р. с. может в нек-рых случаях зависеть не от действующих активных сил, а только от вида связи. Напр., если для тела Р. с. связано является гладкая (липийная трения) поверхность, то Р. с. направлена по нормали к этой поверхности.

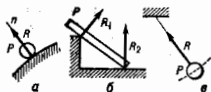


Рис. 1.

На рис. 1 показано, как направлены Р. с. в случаях, когда связями являются гладкая поверхность (а), гладкая опора (б), гибкая нить (с). В других случаях направление Р. с. заранее неизвестно. На рис. 2 показаны гладкий цилиндр, шарнир (подшипник, а) и гладкий сферич. шарнир (б), для к-рых Р. с. представляются соответственно двумя (R_x, R_y) и тремя (R_x, R_y, R_z) составляющими. Для шароховатой связи Р. с. имеет две составляющие: нормальную и касательную, наа. силой трения.

При решении задач Р. с. определяются из ур-ний равновесия или движения рассматриваемой механич. системы. В задачах динамики в общем случае, когда о направлениях Р. с. заранее ничего неизвестно, механич. систему рассматривают как свободную, а к её телам прилагают нек-рые силы, подбираемые так, чтобы во всё время движения выполнялись условия, налагаемые на систему связями; эти силы и наз. Р. с.

РЕАКЦИИ ФУНКЦИИ (отклика функция) в статистической физике — ф-ция, представляющая реакцию статистич. системы на зависящие от времени внеш. возмущение. Если на систему действует зависящее от времени внеш. силы $\mathcal{F}_j(t)$ (напр., электрич. или магн. поля), то вызываемое им возмущение можно представить в виде добавки к гамильтониану члена

$$H_t = - \sum_{j=1}^n \mathcal{F}_j(t) \alpha_j. \quad (1)$$

Предполагая, что $\mathcal{F}_j(t)$ включается адиабатически, т. е. при $t \rightarrow -\infty$ $\mathcal{F}_j(t)$ ведёт себя как $\exp(\epsilon t)$, где $\epsilon > 0$. Здесь $\mathcal{F}_j(t)$ имеет смысл «силы», с к-рой внеш. поле действует на сопряжённую ему величину α_j , характеризующую статистич. систему [напр., если $\mathcal{F}_j(t) =$

электрич. или магн. поля, то α_j — компоненты вектора поляризации или намагниченности).

Р. ф. системы на возмущение (1), т. е. вызываемым изменением ср. значений $\langle \alpha_j \rangle \langle \alpha_j \rangle_0$ — значение величин $\langle \alpha_j \rangle$ в состоянии равновесия статистического, равна

$$\langle \alpha_j \rangle - \langle \alpha_j \rangle_0 = - \int_{-\infty}^t x_{jk}(t-t') \mathcal{F}_k(t') dt', \quad (2)$$

где $x_{jk} = \langle \alpha_j(t) - \langle \alpha_j \rangle_0, \alpha_k(t') - \langle \alpha_k \rangle_0 \rangle$ — Р. ф. системы на возмущение $\mathcal{F}_k(t')$, подразумевается суммирование по двойным индексам, скобки $\langle \dots, \dots \rangle$ означают запаздывающую Грина функцию. Выражение (2) для реакции системы наз. Кубо формулами и даёт микроскопич. выражения для тенаора электропроводности, магн. восприимчивости, диэлектрич. проницаемости. Если возмущение системы пространственно-неоднородно, то Р. ф. зависит как от времени, так и от пространственной координаты (см. Грина — Кубо формулы). Д. Н. Зубарев.

РЕАКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ (радиационное трение) — сила, действующая на заряд, частицу со стороны создаваемого его поля эл.-магн. излучения.

Движение заряда с ускорением приводит к излучению эл.-магн. волн. Эл.-магн. волны уносят энергию и импульс. Поэтому система движущихся с ускорением зарядов не является замкнутой: в ней не сохраняются энергия и импульс. Такая система ведёт себя как механич. система при наличии сил трения (диссипативная система), к-рые вводятся для описания факта не сохранения энергии в системе вследствие её взаимодействия со средой. Совершенно так же передачу энергии (и импульса) заряд. частицей эл.-магн. полю излучения можно описать как «лучистое (радиационное) трение». Зная термаую в единицу времени энергию (т. е. интенсивность излучения), можно определить «силу трения». В случае электрона, движущегося в огранич. области со скоростью, малой по сравнению со скоростью света в вакууме c , интенсивность излучения составляет

$$I = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} w^2,$$

где w — ускорение. Если движение носит приближённо-периодич. характер, то соответствующая сила трения выражается ф-лой, полученной впервые Х. Лоренцем (Н. Lorentz):

$$F = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \frac{dw}{dt}.$$

Р. и. приводит к затуханию колебаний заряда, что проявляется в уширении спектральной линии излучения (т. е. естественная ширина спектральной линии).

Повять природу Р. и. можно след. образом. Создаваемое ускоренно движущимся электромом поле, имеющее на больших расстояниях характер бегущей волны, отл. от нуля и в области вблизи заряда. Действие этого поля (собственного поля) на заряд и даёт Р. и. Необходимость учёта действия заряда на самого себя (через создаваемое им поле) приводит к принципиальным трудностям, тесно связанным с проблемой структуры электрона, природы его массы и др. (см. Электродинамика классическая).

Строго постановка задачи состояла бы в следующем. Имеется динамич. система из зарядов и эл.-магн. поля. Она описывается двумя связанными системами уравн.: ур-ниями движения частиц в поле и ур-ниями поля, определяющегося расположением и движением заряд. частиц. Практически имеет смысл лишь приближённая постановка задачи методом последоват. приближений. Напр., сначала находится движение электрона в заданном поле (т. е. без учёта собств. поля), затем — поле заряда по его заданному движению и далее, в качестве поправки, — влияние этого поля на движение заряда, т. е. Р. и. Такой метод даёт хорошие результаты

для излучения, с длиной волны $\lambda \gg r_0 = e^2/mc^2$ ($r_0 \approx 2.10^{-13}$ см — «классич. радиус» электрона). Реально уже при $\lambda \sim h/m_e c \approx 10^{-10}$ см необходимо учитывать квантовые эффекты. Поэтому приближённый метод учёта Р. и. справедлив во всей области применимости классич. электродинамики.

Квантовая электродинамика в принципиальном отношении сохраняет тот же подход к проблеме, основанный на методе последоват. приближений (возмущенной теории). Но её методы позволяют учесть Р. и. т. е. действие собств. поля на электрон, практически с любой степенью точности; причём не только диссипативную часть Р. и. (затухание спектральных линий), но и «потенц.» её часть, т. е. эфф. изменение инеш. поля, в к-ром движется электрон. Это проявляется в изменении энергетич. уровней и эфф. сечений процессов столкновений (см. Радиационные поправки). Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Клеяков Н. П., Силы торможения излучением и излучение заряженных частиц, УФФ, 1985, т. 148, в. 2, с. 317. В. В. Берестетский.

РЕБИНДРА ЭФФЕКТ (адсорбционное понижение прочности) — уменьшение поверхностной (межфазной) энергии вследствие физ. или хим. процессов на поверхности твёрдых тел, приводящее к изменению его механич. свойств (снижению прочности, возникновению хрупкости, уменьшению долговечности, повышению пластичности и др.). К. Р. э. приводит адсорбция поверхностно-активных веществ, смачивание (особенно твёрдых тел расплавами, близкими по атомно-молекулярной природе), электростатич. заряд на поверхности, хим. реакци. Открыт П. А. Ребиндром в 1928.

Лит.: Ребиндер П. А., Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика, Избр. труды, М., 1979.

РЕВЕРБАЦИЯ (от ср.-век. лат. reverberatio — отражение) — постепенное затухание звука в закрытых помещениях после выключения его источника. Воздушный объём помещения представляется собой колебат. систему с большим числом собственных частот. Собственные колебания, возбуждаемые источником звука, характеризуются своими коэф. затухания (см. также Поглощение звука) и поэтому затухают неодновременно. Длительность Р. определяется в зависимости от помещения и т. е. временем, в течение к-рого интенсивность звука уменьшается в 10^6 раз, а его уровень снижается на 60 дБ. Время Р. характеризует акустич. качество помещения (см. также Архитектурная акустика). Оно тем больше, чем больше объём помещения и чем меньше поглощение звука.

Р. наз. также послезвучание, наблюдаемое в море в результате отражения и рассеяния исходного звука от дна (донына Р.) и неоднородностей водной среды (объёмная Р.).

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. regeneratio — возрождение, возобновление) и р. д. о. ф. и з. и к. е. — компенсация потерь динамической системы за счёт подключения к ней источника энергии и устройства, регулирующего связь между ними. Для Р. используются двухполюсники с падающей вольт-амперной характеристикой (век-рые газоразрядные приборы, туннельные диоды) или цепь положит. обратной связи. Возможна на параметр. Р., возникающая в колебат. системе при периодич. изменении одного из её энергетич. элементов (ёмкость, индуктивности) (см. Параметрическая генерация и усиление электромагнитных колебаний). Полная компенсация потерь приводит к возникновению автоколебаний, неполая — к возрастанию времени затухания свободных колебаний в системе.

Лит.: Основы теории колебаний, 2 изд., М., 1988.

РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДЫ — светочувствит. материалы, в к-рых записываемое интерференц. поле инициирует возникновение соответственной ему пространственной модуляции по крайней мере одного из параметров: коэф. поглощения α , показателя преломления n или толщины материала d .

Фотондуплиров. изменение α используется для регистрации амплитудных голограмм, α изменение n и d — для записи фазовых и рельефно-фазовых голограмм. При одноврем. изменении α и n в Р. г. с. формируется амплитудно-фазовая голограмма.

В зависимости от соотношения d и периода регистрируемой интерференц. картины (d различают двумерные ($d/\lambda \ll 1$) и трёхмерные ($d/\lambda \gg 1$) Р. г. с. Если при этом $d \approx 1$ мкм, то Р. г. с. наз. тонкослойной трёхмерной, а в случае, когда d достигает $10^3 \div 10^6$ мкм, — глубокой трёхмерной (см. *Голография*).

Иницированные светом воздействием изменения параметров Р. г. с. могут быть обратимыми (реверсивными) или носить необратимый характер. Эти изменения могут происходить непосредственно в процессе записи (d и n а м и ч е с к и е среды) или в результате дополнит. обработки материала после экспонирования (среды со скрытым изображением). При постэкспоз. обработке скрытое изображение многократно усиливается, поэтому Р. г. с. со скрытым изображением, как правило, обладают значительно более высокой чувствительностью, чем динамич. Р. г. с.

Динамические Р. г. с. с изменяющимся при экспонировании показателем преломления n наз. фоторефрактивными м.и. Среди последних различают Р. г. с. с локальным и нелокальным откликом. В Р. г. с. с локальным откликом пространственное распределение фотондуплированного изменения показателя преломления $\Delta n(r)$ при записи синусоидальной картин с единичным контрастом (см. *Контраст оптический*) интерференц. поля синфазно или противфазно распределению интенсивности регистрируемого поля $I(r)$, в Р. г. с. с нелокальным откликом $\Delta n(r)$ и $I(r)$ сдвинуты по фазе. Характерной особенностью трёхмерных фоторефрактивных Р. г. с. является взаимодействие в объёме среды запираемого излучения с наведённым им фазовой голограммой, к-рое обуславливает энергообмен между интерферирующими пучками и приводит к изменению пространственной структуры голограммы в процессе записи. Эти изменения ограничивают дифракц. эффективность η (см. *Динамическая голография, Голограммные оптические элементы*).

Для неискажённого воспроизведения волнового поля голограммой необходимо, чтобы Р. г. с. обеспечивала адекватную запись всех пространственно-частотных компонент регистрируемой на ней интерференц. картины. Поэтому важнейшей характеристикой Р. г. с. является ф-ция передачи контраста (ФПК), т. е. зависимость амплитуды записанной в Р. г. с. синусоидальной структуры (решетки) от пространственной частоты этой структуры. Непостоянство ФПК в пределах пространственно-частотного спектра регистрируемой интерференц. картины разл. образом влияет на качество изображения, восстановленного голограммами разл. типа: для *Фурье голограмм* оно приводит к ограничению поля зрения, для *Френеля голограмм* — к падению разрешения в восстановленном изображении. При этом разрешающая способность R Р. г. с., необходимая для неискажённого воспроизведения волнового поля, определяется макс. пространственной частотой голограммы и может быть вычислена по ф-ле

$$R \geq 2n \sin \theta / \lambda \quad (\text{мм}^{-1}),$$

где n — показатель преломления Р. г. с., 2θ — макс. угол между интерферирующими пучками в среде, λ — длина волны излучения в воздухе. При записи голограмм во встречных пучках R достигает $(6-7) \cdot 10^6$ мм⁻¹.

Чувствительность Р. г. с. характеризуют либо экспозицией $H_{\text{отт}}$, при к-рой достигаются макс. значения $\eta_{\text{макс}}$; либо величиной $S_{\eta=1\%}$, обратно пропорциональной экспозиции, приходившейся на 1% η .

Большинство практич. приложений голографии базируется на использовании галогенидо-серебряных фотогр. материалов, слоях бихромированной желатин

(БХЖ) и фототермопластика. Краткие сведения об этих материалах и других наиб. распространённых Р. г. с. приведены в табл.

Наиболее распространённые регистрирующие голографические среды

Тип голограмм	Регистрирующие голографические среды, используемые для записи голограмм		Параметры регистрирующих голографических сред		
	нереверсивные	реверсивные	$\eta_{\text{макс}}$ (%)	R (мм ⁻¹)	$H_{\text{отт}}$ Дж/см ²
Двумерные	амплитудные	Фотографические материалы	3	$2,5 \times 10^6$	10^{-4}
	фазовые	Обедающие фотографические материалы	$\sim 0,5$	$3 \cdot 10^6$	$\sim 10^{-1}$
	рельефно-фазовые	Фотографические материалы Аморфные полупроводники	70 30	$2 \cdot 10^6$ $2 \cdot 10^6$	~ 1 6
Тонкослойные трёхмерные	амплитудно-фазовые	Фотографические материалы	50	$5 \cdot 10^3$	$\sim 10^{-3}$
	фазовые	БХЖ Обедающие фотографические материалы	80 80	$5 \cdot 10^3$ $5 \cdot 10^3$	$\sim 10^{-3}$ 10^{-4}
	амплитудно-фазовые	Фотографические органические (неорганические) материалы	10 (63)	$5 \cdot 10^3$	$0,1-1,5$ (10^{-3})
Глубокие трёхмерные	фазовые	Электронно-оптические кристаллы	80 15	10^4 $\sim 10^4$	1,6 10^{-3}
		Резонанс Фотополимеры	80 90	$\sim 10^4$ $2 \cdot 10^4$	$1-2$ 3

Лит.: Несеребряные и необычные среды для голографии, под ред. В. А. Барачевского, Л., 1978; Регистрирующие среды для азобизвольной голографии и киноголографии, под ред. Г. А. Соболева, Л., 1978; Новые регистрирующие среды для голографии, под ред. В. А. Барачевского, Л., 1983; Шварц К. К., Физика оптической записи в дисперсных и изотропных средах, Рига, 1982; Свойства светочувствительных материалов и их применение в голографии, под ред. В. А. Барачевского, Л., 1987.

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ — раздел матем. статистики, посвященный методам анализа зависимости одной физ. величины Y от другой — x . Пусть в точках x_n независимой переменной x получены измерения Y_n . Нужно найти зависимость ср. значения величин Y от величин x , т. е. $\bar{Y}(x) = f(x|a)$, где a — вектор неизвестных параметров a_i (i — вектор, компоненты к-рого являются a_i). Ф-цию $f(x|a)$ наз. ф-цией регрессии. Обычно предполагают, что $f(x|a)$ является линейной ф-цией параметров a , т. е. имеет вид

$$f(x|a) = \sum_{i=1}^l a_i \varphi_i(x), \quad (1)$$

где $\varphi_i(x)$ — заданные ф-ции. В этом случае матрицу $A_{ni} = \varphi_i(x_n)$ наз. регрессионной матрицей. Для определения параметров a_i обычно используют *наименьших квадратов метод*, т. е. оценки a_i определяют из условия минимума функционала

$$\Phi = \sum_{n=1}^N \left(Y_n - \sum_{i=1}^M A_{ni} a_i \right)^2 / \sigma_n^2, \quad (2)$$

где σ_n^2 — дисперсии ошибок измерений Y_n в предположении, что они не коррелированы, и из минимума функционала

$$\Phi = \sum_{n,m} \left(Y_n - \sum_{i=1}^M A_{ni} a_i \right) (R^{-1})_{nm} \left(Y_m - \sum_{i=1}^M A_{mi} a_i \right)$$

для коррелиров. измерений с корреляц. матрицей R . В качестве ф-ций $\varphi_i(x)$ при небольших I ($I \leq 5$) обычно служат степенные ф-ции $\varphi_i(x) = x^i$. Часто используют ортогональные и нормированные полиномы на множестве x_n :

$$\varphi_i(x) = \sum_{k=1}^i c_k x^k, \quad \sum_n \varphi_i(x_n) \sigma_n^{-2} \varphi_j(x_n) = \delta_{ij}. \quad (3)$$

В этом случае легко найти оценку \hat{a}_i :

$$\hat{a}_i = \sum_n \varphi_i(x_n) Y_n. \quad (4)$$

Отсюда следует, что вычисление \hat{a}_i не зависит от вычисления других \hat{a}_j .

Популярно использование в качестве $\varphi_i(x)$ сплайнов $B_i(x)$, к-рые обладают двумя осн. свойствами: а) $B_i(x)$ — полином заданной степени; б) $B_i(x)$ отличен от нуля в огранич. окрестности точки x_i .

При поиске ф-ции регрессии в виде (1) естественно возникает вопрос о кол-ве членов I в сумме (1). При малом значении I нельзя достичь хорошего описания $\hat{Y}(x)$, а при большом — велики статистич. ошибки ф-ции регрессии.

В предположении, что вектор ошибок измерений Y_n распределён нормально, можно использовать *статистические критерии* и выбрать то I , к-рое является оптимальным при данном множестве измерений Y_n . В случае, когда $\varphi_i(x)$ — ортогональные полиномы, это особенно просто. Как видно из (4), дисперсия \hat{a}_i равна 1 и по значению a_{I-1} можно легко заключить, нужно ли включать $\varphi_{I-1}(x)$ в сумму (1).

Лит.: Клейнков Н. П., Соколов С. Н., Анализ и планирование экспериментов методом максимума правдоподобия, М., 1984; Ковдвал М. Дж., Стьюарт А., Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973; Себер М. Дж., Линейный регрессионный анализ, пер. с англ., М., 1980. В. П. Жигуров.

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ — придание смысла расходящимся выражениям с помощью подходящего предельного процесса. Р. тесно связана с классиф. методами суммирования расходящихся рядов и интегралов; применяется в теории обобщённых ф-ций, в квантовой теории поля и в др. областях теоретич. физики.

Каждая локально суммируемая ф-ция $f(x)$ в области $f \in D'(R)$ задаёт распределение (*обобщённую функцию*) $f \in \mathcal{D}'(R)$ по правилу

$$(f, \varphi) = \int f(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(O)$$

(такое распределение наз. регулярым). Если же $f(x)$ не является локально суммируемой, то интеграл справа расходится и для придания ему смысла используется Р. При этом разл. Р. порождают разл. распределения, и выбор конкретной Р. диктуется решаемой физ. задачей.

Пример. Ф-ция x^{-1} не является локально суммируемой в R^1 . Она имеет регуляризацию $px^{-1}, (x \pm i0)^{-1}, (x - i0)^{-1}$, где

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = V. P. \int \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left\{ \int_{-\infty}^{-\varepsilon} + \int_{+\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right\},$$

$$\left(\frac{1}{x+i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int \frac{\varphi(x)}{x+i0} dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(R^1),$$

где $V. P.$ означает *главное значение интеграла*. Остальные Р. ф-ции x^{-1} получают линеинными комбинациями приведенных.

Р. применяется также для представления данного распределения в виде предела последовательности регуляризованных распределений. Напр., *дельта-функция Дирака* имеет Р.

$$(\delta(x), \varphi(x)) = \varphi(0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{1}{\pi} \int \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(R^1).$$

Обычно Р. распределений используется при перенормировании распределений. Напр.,

$$\left(\frac{1}{x+i0} \cdot \frac{1}{x+i0}, \varphi \right) = \left(\frac{1}{(x+i0)^2}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int \frac{\varphi(x) dx}{(x+i\varepsilon)^2}, \quad \varphi \in \mathcal{D}(R^1).$$

Известный физ. пример — перемножение одночастотных ф-ций в квантовой теории поля. Часто, напр. при перемножении причинных ф-ций, такая процедура не приводит к однозначному ответу и требует доопределения, согласованного с физ. контекстом задачи (см. *Ультрафиолетовые расходимости, Перенормировки*). Пример подобного доопределения — R -операция Боголюбова — Парасюка. О др. конкретных приёмах Р., применяемых в физ. приложениях, см. в ст. *Регуляризация расходимостей в квантовой теории поля*.

Лит.: Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантовых полей, 4 изд., М., 1984; Вэддл и Иррив В. С., Обобщённые функции в математической физике, 2 изд., М., 1979. В. В. Жигуров.

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ РАСХОДИМОСТЕЙ в квантовой теории поля (КТП) — вспомогат. операция, заключающаяся в замене *пропагаторов* или интегралов от их произведений (соответствующих локальной КТП) на некие аппроксимирующие их выражения, не содержащие ультрафиолетовых расходимостей или соответствующих им в координатном представлении сингулярностей на световом конусе. Такие регуляризованные интегралы явно вычисляются (в импульсном представлении), а затем уже в вычисленных выражениях производят операцию, обратную введению регуляризации, т. е. переходят к реальному физ. пределу. УФСингулярности при этом выделяются в виде аддитивных составляющих, имеющих простую (напр., полиномиальную) структуру по внеш. импульсам.

Необходимость Р. р. наиб. просто увидеть в x -представлении. В квантовополевых расчётах приходится иметь дело с произведениями пропагаторов $\Delta(x)$, обладающих сингулярностями типа полюса $1/x^2$ и *дельта-функции Дирака* по квадрату 4-мерного интервала $x^2 = (x^0)^2 - x^2$ [здесь x^0, x — точка пространственно-времени; используется система единиц, в к-рой $\hbar = c = 1$]. Ясно, что квадраты и более высокие степени таких сингулярностей [напр., $\delta^2(x^2)$] не определены математически даже в смысле *обобщённых функций*. Для соответствующего доопределения удобно иметь регулярные (т. е. не имеющие особенностей) приближения к Δ или к произведениям нескольких Δ . Такие приближения и получают посредством вспомогательной Р. р.

В квантовополевых вычислениях по теории возмущений получили распространение неск. разл. регуляризаций. Среди них наиб. употребительны следующие,

Регуляризация обрезанием состоит во введении конечного верхнего предела Λ (называемого также импульсом обрезания) при интегрировании по 4-импульсам виртуальных частиц. Так, напр., фейнмановский интеграл, отвечающий простей-

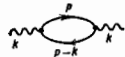


Диаграмма вакуумной поляризации фотона; $k, p, p-k$ — 4-импульсы соответственно фотона и виртуальных электрона и позитрона.

шей, однопетлевой, диаграмме поляризации вакуума (рис.) в квантовой электродинамике

$$\Pi^{\mu\nu}(k) = (i/\pi^2) \int d^4p \text{Sp} \{ \gamma^{\mu} S^c(p) \gamma^{\nu} S^c(p-k) \}, \quad (1)$$

при регуляризации обрезанием принимает вид

$$\text{reg} \Pi^{\mu\nu}(k) = (i/\pi^2) \int_{|p| < \Lambda} d^4p \text{Sp} \{ \gamma^{\mu} S^c(p) \gamma^{\nu} S^c(p-k) \}, \quad (2)$$

где символ $|p| < \Lambda$ под знаком интеграла обозначает, что по всем четырём компонентам 4-импульса p интегрирование проводится в пределах от $-\Lambda$ до $+\Lambda$. В приведенных ф-лах $\Pi^{\mu\nu}$ — поляризационный оператор, γ^{μ} — Дирака матрицы ($\mu = 0, 1, 2, 3$), $S^c(p)$ — пропагатор электрона в импульсном представлении (см. Фейнмана диаграммы).

Вычисление по ф-ле (2) с помощью стандартной техники даёт явное выражение, к-рое в пределе больших (по сравнению с массой электрона m и модулем внеш. импульса $k = \sqrt{k^2}$) значений Λ имеет вид

$$\text{reg} \Pi^{\mu\nu}(k) = P^{\mu\nu}(k, \Lambda) + \tilde{\Pi}^{\mu\nu}(k), \quad (3)$$

где $P^{\mu\nu}$ — полином 2-й степени по компонентам 4-вектора k^{μ} с коэф., пропорц. Λ^2 и $\ln(\Lambda^2)$, а $\tilde{\Pi}^{\mu\nu}$ — конечная ф-ция от k^{μ} и m^2 . Её явный вид несуществен. Отметим лишь, что при больших k^2 она имеет логарифмич. асимптотику

$$\tilde{\Pi}^{\mu\nu}(k) \propto (g^{\mu\nu} k^2 - k^{\mu} k^{\nu}) \frac{1}{3} \ln k^2, \quad (4)$$

где $g^{\mu\nu}$ — метрич. тензор пространства-времени Минковского. Представление (3) оказывается удобным для проведения перенормировки, т. е. устранения бесконечностей. Результативно оно сводится к вычитанию из правой части (3) первого, сингулярного в пределе $\Lambda \rightarrow \infty$ слагаемого. Поскольку разбиение $\text{reg} \Pi$ на слагаемые P и $\tilde{\Pi}$ содержит произвол, то возникает вопрос о степени однозначности определения конечной части $\tilde{\Pi}^{\mu\nu}$ поляризац. оператора. Одно из условий, к-рому должно удовлетворять $\tilde{\Pi}$, — условие поперечности $k_{\mu} \tilde{\Pi}^{\mu\nu}(k) = 0$, вытекающее из требования калибровочной инвариантности. Это условие диктует тензорную структуру матрицы $\tilde{\Pi}$:

$$\tilde{\Pi}^{\mu\nu}(k) = (g^{\mu\nu} k^2 - k^{\mu} k^{\nu}) \pi(k^2), \quad (5)$$

где $\pi(k^2)$ — нек-рая скалярная ф-ция от k^2 . Как можно показать, после этого остаётся ещё однопараметрич. произвол, к-рый, напр., можно фиксировать условием $\pi(0) = 0$.

Регуляризация Паули — Вилларса представляет собой специфическую модификацию одночастичного пропагатора. Её простейший вариант сводится к вычитанию из пропагатора Δ_m для нек-рого квантового поля массой m такого же пропагатора, но соответствующего большой фиктивной массе M : $\Delta_m \rightarrow \text{reg} \Delta_m = \Delta_m - \Delta_M$. Так, напр., в импульсном представлении для скалярного поля

$$\text{reg} D_m(p) = \frac{1}{m^2 - p^2} - \frac{1}{M^2 - p^2} = \frac{1}{m^2 - p^2} \left(\frac{M^2 - m^2}{M^2 - p^2} \right). \quad (6)$$

Как видно, Р. р. Паули — Вилларса существенно меняет поведение пропагаторов в УФ-области при $p^2 \rightarrow \infty$

идл, что эквивалентно, в окрестности светового конуса [где регуляризация типа (6) убрает наиб. сильные, не зависящие от массы сингулярности по переменной x^2].

В квантовой электродинамике в целях сохранения калибровочной инвариантности применяют особый вариант Р. р. Паули — Вилларса, при к-ром замкнутые электронные циклы регуляризуют как целое. Так, напр., при Р. р. диаграммы, изображённой на рис., подитеральное выражение в правой части (1) регуляризуют целиком, т. е. путём вычитания из него аналогичного выражения, в к-ром в пропагаторах S^c вместо массы электрона m стоит большая висомогат. масса M . Такая процедура приводит к выражению, к-рое в пределе больших значений регуляризующей массы M имеет структуру, подобную (3), причём вместо первого слагаемого в правой части стоит полином $P^{\mu\nu}(k)$ 2-й степени по k с коэф., сингулярно зависящими от M .

$$\text{reg} \Pi^{\mu\nu}(k) = i/\pi^2 \int d^4p \text{Sp} \{ \gamma^{\mu} S^c(p) \gamma^{\nu} S^c(p-k) \}. \quad (7)$$

Не вдаваясь в техн. детали, отметим, что результат интегрирования (7) в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$ представим в виде (3), где вместо первого слагаемого правой части стоит полином $P^{\mu\nu}$ с коэф., содержащими сингулярности типа $1/\varepsilon$. Техн. преимущество размерной Р. р. состоит в том, что она сохраняет свойства симметрии и соответствующей инвариантности перергуляризованных выражений. В используемом примере речь идёт о калибровочной инвариантности эл.-магн. поля. Результат явного вычисления выражения (7) удовлетворяет свойству поперечности, т. е. размерно регуляризованный поляризац. оператор пропорционален поперечному тензору: $\text{reg} \Pi^{\mu\nu} \sim (g^{\mu\nu} k^2 - k^{\mu} k^{\nu})$, в то время как выражение (2) этим свойством не обладает.

Лит.: Pauli W., Villars F., On the invariant regularization in relativistic quantum theory, Rev. Mod. Phys., 1949, т. 21, p. 434; Нироу Г. В. и др., Regularization and renormalization of gauge fields, Nucl. Phys., 1972, т. В4, p. 189; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Квантовые поля, М., 1980, § 23. Д. В. Ширков.

РЕДЖЕ ПОЛЮСОС МЕТОД (метод комплексных угловых моментов) в квантовой механике и квантовой теории поля (КТП) — теоретич. подход, позволяющий связать асимптотику амплитуд рассеяния частиц при высоких энергиях с особенностями парциальных амплитуд $f_j(t)$ перекрёстного (t) канала (см. Перекрёстная симметрия) в плоскости комплексного угла. момента j .

Аналитич. продолжение парциальных амплитуд из области физ. значений угла. момента $j = 0, 1, 2, \dots$ на комплексные значения впервые было использовано Т. Редже [1] при изучении свойств амплитуд рассеяния в релятивистской квантовой механике. Наиб. распространение Р. п. м. получил в теории взаимодействия частиц при высоких энергиях [2], где при его выводе [3] используются такие общие свойства амплитуд рассеяния в КТП, как аналитичность, перекрёстная симметрия и унитарность. Исследование двухчастичного условия унитарности в t -канале показывает, что амплитуды $f_j(t)$ должны иметь полюсы в j -плоскости, положение к-рых зависит от переменной t (квадрата переданного в рассеянии 4-импульса), — действительные и мнимые полюсы, или полюсы Редже. Вблизи полюса парциальная амплитуда $f_j(t)$ имеет вид

$$f_j(t) = \frac{\gamma(t)}{j - \alpha(t)}, \quad (1)$$

где $\alpha(t)$ — траектория полюсов Редже (траектория Редже), а $\gamma(t)$ — его вычет. Каждый полюс Редже обладает

определ. набором сохраняющихся квантовых чисел, как *барионное число*, *странность*, *изотопический спин*, *чётность* и т. д. Поскольку в релятивистской теории аналитич. продолжение амплитуд $f(t)$ осуществляется отдельно для чётных и нечётных значений момента j , то полюсы Редже характеризуются также сохраняющимся квантовым числом — «сигнатурой» $\sigma = \pm 1$, k -рая определяет чётность момента при целых значениях j : $\sigma = (-1)^j$. Вклад полюса Редже в амплитуду бинарного процесса $1+2 \rightarrow 3+4$ при высоких энергиях, $s = (p_1 + p_2)^2 \approx 2m_1^2 s_0$, и небольших значениях квадрата переданного импульса $t = (p_1 - p_3)^2$ (здесь p_i и m_i — импульс и масса i -й частицы, s_0 — энергия частицы 1 в лаб. системе, s — квадрат полной энергии в системе центра переноса; используется система единиц, в k -рой $c = 1$) записывается в виде

$$T(s, t) = \gamma(t) \eta(\alpha(t)) (s/s_0)^{\alpha(t)}, \quad (2)$$

где $s_0 = 1 \text{ ГэВ}^2$, $\eta(\alpha(t)) = -1 + \text{sech} p(-i\pi\alpha(t))/\text{sin}(\pi\alpha(t))$ — сигнатурный множитель, а вычет $\gamma(t)$ представляется в виде произведения вершин: $\gamma(t) = g_{123} g_{34}$ (что наз. свойством факторизации). Такой амплитуде можно поставить в соответствие график (рис. 1), отвечающий обмену полюсом Редже в t -канале — редже оном (R). В области рассеяния ($t \leq 0$) вычет и траектория полюса Редже являются вещественными, а при положительн. значениях t , превышающих порог образования частицы $\alpha(t)$ становится комплексной.

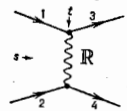


Рис. 1.

реальных адронов, траектория $\alpha(t)$ становится комплексной.

Важное свойство полюсов Редже — их связь со спектром частиц и резонансов. Если вещественная часть $\alpha(t)$ в области положит. t проходит через целое значение n (для фермионов — полуцелое), чётное для $\sigma = +1$ и нечётное для $\sigma = -1$, то амплитуда (2) соответствует обмену в t -канале частицей или резонансом (при условии, что мнимая часть $\alpha(t)$, $\text{Im}\alpha(t)$, связанная с шириной резонанса, невелика) со спином $j = n$. Обмен полюсом Редже учитывает вклад всех частиц и резонансов, расположенных на траектории с данными квантовыми числами, и позволяет установить тесную связь между спектром

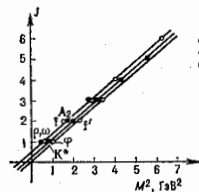


Рис. 2.

частиц и асимптотикой амплитуды рассеяния при высоких энергиях. При описании бинарных реакций обычно учитываются те траектории Редже, на k -рых расположены известные частицы и резонансы: p , ω , f , A_2 , ρ , N и др. На рис. 2 приведены известные бозонные траектории Редже. Эти траектории с хорошей степенью точности являются линейными, т. е. $\alpha(t) = \alpha(0) + \alpha' t$, α' — универсальным наклоном $\alpha' \approx 0,9 \text{ ГэВ}^{-2}$. Кроме того, имеет место вырождение траекторий по сигнатуре ($\alpha_p = \alpha_\omega$, $\alpha_\rho = \alpha'_\rho$) и изоспину ($\alpha_\rho = \alpha_\omega$, $\alpha_\rho = \alpha'_\rho$). Удивительная линейность траекторий Редже, обнаруженная на опыте, привела к созданию дуальных и струнных моделей адронов (см. *Дуальность*, *Струнные модели адронов*). Понятие дуальности, утверждающее, что суммарный вклад всех резонансов в прямом (s) канале равен сумме вкладов всех полюсов Редже в перекрёстном (t или u) канале, оказалась весьма полезным для понимания свойств взаимодействия адронов при высоких энергиях. В струнных моделях адроны рассматриваются как протяжённые объекты — струны (см. *Струна релятивист-*

ская), квантование k -рых приводит к возникновению последовательности частиц, расположенных на линейно растущих траекториях Редже. В рамках *качественной хромодинамики* (КХД) линейность траекторий Редже, по-видимому, тесно связана с невылетанием цветных объектов — кварков в глюоны.

Выделенное положение в Р. п. м. занимает полюс Померанчука (номерон, P), k -рый является самым правым полюсом в j -плоскости (по крайней мере в области $t \leq 1 \text{ ГэВ}^2$) и определяет величину амплитуды дифракц. процессов (*дифракционного рассеяния*, *дифракционной диссоциации*). Этот полюс имеет полонител. сигнатуру, чётность и G -чётность, массния $l = 0$. Пока ясно, какие резонансы расположены на траектории Померанчука $\alpha_P(t)$. Первоначально предполагалось, что $\alpha_P(0) = 1$ и полные сечения взаимодействия адронов при $s \rightarrow \infty$ не зависят от энергии. Однако в связи с наблюдаемым на опыте ростом полных сечений с увеличением энергии более предпочтительным считается вариант теории с $\alpha_P(0) > 1$ — т. н. надкритич. теория Померона (описывающая т. н. особенность Померанчука).

Дифференц. сечения бинарной реакции, отвечающие обмену полюсом Редже в t -канале, имеет при высоких энергиях простой вид:

$$\frac{d\sigma}{dt} = f(t) (s/s_0)^{2\alpha(t)-2}. \quad (3)$$

Ф-ция $f(t) \sim \gamma^2(t) |\eta(\alpha(t))|^2$ не фиксируется теорией. Зависимость от энергии полностью определяется траекторией $\alpha(t)$ полюса Редже, k -рый даёт вклад в данную реакцию. Найдённые из анализа эксперим. данных о бинарных процессах траектории полюсов Редже прекрасно согласуются с траекториями, полученными из спектра частиц и резонансов. Наиб. удобными для проведения такого анализа являются реакции черзрядок типа $\pi^+ p \rightarrow \pi^+ n$, $\pi^- p \rightarrow \pi^0 n$, $K^- p \rightarrow \bar{K}^0 n$, в k -рые могут давать вклад только p или A_2 полюсы Редже. Дифференц. сечения бинарных процессов (в частности, реакций упругого рассеяния адронов), согласно ф-ле (3), сосредоточены в узкой области переданных импульсов $|t|$, ширина k -рой логарифмически убывает с ростом энергии. Это явление в упругих процессах обычно называют сокращением угла дифракционного конуса. Сокращение конуса угл. распределения наблюдается экспериментально во всех бинарных реакциях. Дифференц. сечения бинарных реакций в области малых t часто записывают в виде

$$\frac{d\sigma}{dt} = F(s) \exp \{ B(s) \cdot t \}, \quad (4)$$

а величину $B(s)$ наз. наклоном дифракционного конуса. В модели полюсов Редже наклона дифракц. конуса логарифмически растёт с увеличением энергии: $B(s) = B_0 + 2\alpha'(0) \ln(s/s_0)$. Величина $\alpha'(0)$, характеризующая рост наклона в процессах упругого рассеяния, определяется наклоном траектории Померанчука $\alpha'_P(0)$, и оказалось, что $\alpha'_P(0) \approx 0,2 \text{ ГэВ}^{-2}$, что заметно меньше, чем α' для др. траекторий Редже. Увеличение наклона $B(s)$ с ростом энергии означает, что квадрат радиуса взаимодействия адронов в модели полюсов Редже растёт по закону $R^2 \sim \alpha' \ln(s/s_0)$.

Полюсы Редже в бинарных реакциях тесно связаны с т. н. мультипериферическими взаимодействиями в процессах множеств. рождения адронов (см. *Множественные процессы*) [4], k -рые в силу условия унитарности определяют мнимые части амплитуд двухчастичных процессов. Взаимодействие адронов является наиб. сильным при низких энергиях, где оно имеет резонансный характер (рис. 3, а). При увеличении нач. энерг. возможно образование виск. частиц или резонансов в результате обмена виртуальной частицей в t -канале (рис. 3, б). Такая мультипериферич. карти-

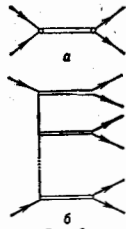


Рис. 3.

на неупругих процессах приводит к реджескому поведению амплитуд уругого рассеяния в др. бинарных реакций. Соответствующая пространственно-ареманная картина отвечает тому, что на большом продольном расстоянии от мишени нач. частица с энергией $E \gg m$ начинает замедляться, последовательно испуская новые частицы и резонансы. С мишенью взаимодействует уже медленная частица, энергия к-рой порядка $\beta^2 m \sim m$ ($\beta < 1$). Ср. число n рожденных частиц логарифмически возрастает с ростом энергии: $n \approx \ln(E/m)$ ($\gamma = \ln(1/\beta)$). Движение замедляющейся частицы в плоскости прицельного параметра представляет собой случайное блуждание с шагом $b_i \approx 1/m$. Следовательно, $b^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2 \approx n/m^2 \approx (\gamma/m^2) \ln(s/s_0)$, и возникает отмечавшийся выше рост эфф. радиуса взаимодействия с увеличением энергии.

В релятивистской квантовой теории полюсы Редже не являются единств. особенностями в j -плоскости. Анализу диаграмм Фейнмана [5] и многочастичных членов условия унитарности [6] показывает, что в j -плоскости возникают движущиеся точки ветвления, связанные с обменом а t -канале неск. полюсами Редже, напр. R и λ померонами (рис. 4). График, отвечающий двухреджеонному ветвлению, соответствует двукратному перерассеянию на составляющих адронах частица. В реджеонной теории сформулированы правила вычисления таких диаграмм [7] и правила, позволяющие сопоставить с каждой диаграммой определ. класс неупругих процессов, приводящих к возникновению её мин.

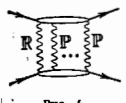


Рис. 4.

ной части [8]. Так, двухполюсовое ветвление связано с дифракц. процессами (рис. 5, а), процессом образова-

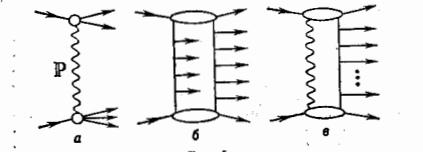


Рис. 5.

ния двух мультипериферич. цепочек (рис. 5, б) и эффектами поглощения в одной мультипериферич. цепочке (рис. 5, в). Эти правила позволяют вычислять характеристики процессов множеств. образования адронов, если известны вклады полюсов Редже и сопровождающих их ветвлений в амплитуду уругого рассеяния адронов.

Сечение дифракц. возбуждения одного из сталкивающихся адронов с образованием адронной системы с большой массой, $M^2 \gg s_0$, характеризуется диаграммой трёхполюсового взаимодействия (рис. 6), к-рое является частным случаем трёхреджеонного взаимодействия. Трёхреджеонные диаграммы используются для описания инклюзивных процессов $ab \rightarrow cX$ при высокой энергии в пределе, когда фейнмановская переменная $x = 2p_1/\sqrt{s} \rightarrow 1$ (здесь p_1 — продольный импульс адрона в системе центра инерции, X — совокупность остальных, регистрируемых адронов).

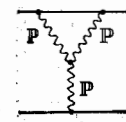


Рис. 6.

При высоких энергиях наб. существуют ветвления, связанные с обменом в t -канале полюсом Редже дикого типа α_i и произвольным числом полюсов Померанчука. Такие ветвления имеют те же сигнатуру, изоспин, G -чётность, что и полюс α_i , однако, вообще говоря, не обладают определ. чётностью. При учёте ветвлений в j -плоскости амплитуды рассеяния не обладают свойством факторизации. Дисперсионный метод вычисления вклада диаграмм Фейнмана, приводящих к движущимся ветвлениям [7], позволяет выразить этот вклад через уругие (рис. 7, а) и неупругие (рис. 7, б) перерассея-

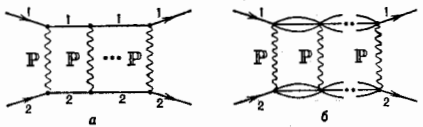


Рис. 7.

ния нач. адронов. Наиб. простой вид имеет вклад полюса Померанчука и всех λ -померонов ветвлений в амплитуду уругого рассеяния в т. н. вильковском приближении, учитывающем только уругие перерассеяния:

$$f(s, b) = \frac{\exp(2i\delta_P(s, b)) - 1}{2i}, \quad (5)$$

где $\delta_P(s, b)$ — амплитуда в пространстве прицельных параметров, соответствующая обмену полюсом Померанчука. При параметризации вычета в форме $\gamma(0)\exp(Rt^2)$ ф-ция $\delta_P(s, b)$ имеет вид

$$\delta_P(s, b) = \frac{\gamma_P(0)n(\alpha_P(0)(s/s_0)^{\alpha_P(0)-1}}{16\pi [R_P^2 + \alpha_P^2 (\ln(s/s_0) - \ln 2)]} \exp X \times \left\{ \frac{b^2}{4 [R_P^2 + \alpha_P^2 (\ln(s/s_0) - \ln 2)]} \right\}, \quad (6)$$

Учёт всех перерассеяний особенно важен в случае, когда $\Delta \equiv \alpha_P(0) - 1 > 0$. При очень высоких энергиях величина $\text{Im}b_P(s, b) \gg 1$ в области $b^2 < 4\alpha_P^2 \Delta \ln^2(s/s_0)$.

В этой области прицельных параметров амплитуда рассеяния в b -пространстве $f(s, b)$, согласно ф-ле (5), близка к $i/2$, что соответствует рассеянию на чёрном шарике. При $b^2 > 4\alpha_P^2 \Delta \ln^2(s/s_0)$ величины $\delta_P(s, b)$ и $f(s, b)$ малы. Амплитуда рассеяния имеет вид, изображённый на рис. 8, а квадрат радиуса взаимодействия и полное сечение взаимодействия адронов растут пропорц. $\ln^2(s/s_0)$, т. е. максимально допустимым, согласно Фурассара ограничению, образом. В теории надкритич. померона с $\Delta > 0$ удаётся преодолеть трудности, связанные с быстрым энергетич. ростом неупругих дифракц. процессов, возникавшие в случае $\alpha_P(0) = 1$.

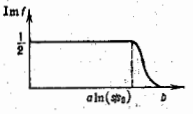


Рис. 8.

Р. п. м. при учёте движущихся ветвлений позволяет понять и количественно описать обширную эксперим. информацию о бинарных процессах при высоких энергиях. Недостаток метода — наличие большого числа феноменологич. параметров, характеризующих траектории и вычеты полюсов Редже. Большое число свободных параметров возникает также при описании в рамках Р. п. м. разл. характеристик процессов множественного рождения адронов, таких, как инклюзивные спек-

ры (см. *Янклаковский процесс*), корреляции и т. д. Эти теоретич. неопределенности могут быть значительно уменьшены при использовании допущений, соображений, основанных на $1/N$ -разложении (где N — число цветов или типов (ароматов) кварков, т. е. $N \approx 3$) в КХД и модели кварк-глюонных струн [9]. В рамках такого подхода с помощью ρ , ω , A_1 , ... сопоставляются планарные диаграммы (рис. 9, а) с полюсом Померанчука — цилиндрические (рис. 9, б). Сильные линии на этих

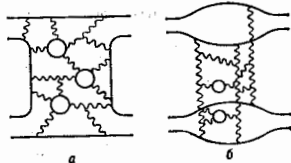


Рис. 9.

рисунках соответствуют кваркам, волнистые — глюонам. Этот метод позволяет получить многочисл. соотношения между траекториями и вычтем разл. полюсов Редже и описать все осн. характеристики процессов множественного рождения адронов: распределение по множественности образующихся частиц, янклавские спектры адронов, корреляции. Модель воспроизводит быстрый рост янклавских спектров (в центр. области *быстро*) с увеличением энергии, приближенный KNO -скейлинг (см. *Масштабная инвариантность*) и его нарушение при энергиях $\sqrt{s} \sim 10^8$ ГэВ. Инклявские спектры адронов выражаются через распределение кварков (дикварков) в сталкивающихся адронах и соответствующие ф-ции фрагментации. Использование реджеонных асимптотик при построении ф-ции фрагментации позволило описать спектры разл. адронов (π^+ , K^+ , K^0 , K^0 , p , n , p , Λ и др.). Полученные результаты обобщаются на процессы взаимодействия адронов и ядер с ядрами.

Лит.: 1) Regge T., Introduction to complex orbital momenta, *Nuovo Cim.*, 1959, т. 14, р. 391; 2) Колдвелл П., Сивая Р. С., Полюса Редже в физике частиц, пер. с англ., М., 1971; 3) Chew G. F., Frautschi S. C., Principle of equivalence for all strongly interacting particles within the S-matrix framework, *Phys. Rev. Lett.*, 1961, в. 7, р. 394; Грибов В. Н., о возможном асимптотическом поведении упругого рассеяния, *«ЯЭТФ»*, 1961, т. 41, с. 687; его же, Парциальные волны с комплексными орбитальными моментами и асимптотическое поведение амплитуды рассеяния, там же, с. 1962; 4) Алт Л. Д., Стангерли А. А., Рубин Л. S., Theory of high energy scattering and multiple production, *Nuovo Cim.*, 1962, т. 26, р. 896; 5) Mandelstam S., Cuts in the angular-momentum plane, *Nuovo Cim.*, 1963, в. 30, р. 1127, 1148; 6) Грибов В. Н., Померанчука И. И., Тер-Мартirosian К. А., Двигнувшиеся точки ветвления в J -плоскости и реджеонные условия унитарности, *«Ядерная физика»*, 1965, т. 6, с. 361; 7) Грибов В. Н., Реджеонная диаграммная техника, *«ЯЭТФ»*, 1967, т. 52, с. 954; 8) Бравадский В. А., Грибов В. Н., Канчели О. В., Характер инклювских спектров и флуктуаций в неупругих процессах, обусловленных множественным обменом, *«Ядерная физика»*, 1973, т. 18, с. 525; 9) Ка Вадло А. В., Тер-Мартirosian К. А., Множественное образование адронов при высоких энергиях в модели кварк-глюонных струн, *«Ядерная физика»*, 1984, т. 39, с. 1545, т. 40, с. 211. А. В. Райбулов.

РЕДЖЕОН (движущийся полюс, полюс Редже) — объект, возникающий при описании амплитуд упругого и неупругого рассеяния при высоких энергиях в рамках метода комплексных угл. моментов. См. *Редже полюсов метод*.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАГНЕТИКИ — кристаллич. и аморфные магнетики (металлы, сплавы, соединения), содержащие редкоземельные элементы — лантаноиды. В более узком смысле Р. м. — вещества, содержащие редкоземельно-лантаноидные (РЗЛ) элементы и обладающие магн. упорядочением (ферро-, ферри- и антиферромагнетизмом).

Природа магнетизма РЗЛ элементов. Магн. моменты атомов обусловлены частично заполненной $4f$ -оболочкой. Внеш. часть электронных оболочек РЗЛ атомов, входящая вне заполненных слоев, соответствующий атому Хе, имеет конфигурацию $4f^{m_1}5s^25p^65d^0+4d^1$, где l принимает значения от 1 до 14. В ряду лантаноидов при возрастании порядкового номера Z от $Z = 58$ до $Z = 71$ число $4f$ -электронов монотонно возрастает от $l = 1$ до $l = 14$. Неаполненность $4f$ -электронной оболочки за исключением лотения (Lu) с $l = 14$ приводит к появлению нескомпенсированного спинового (S) и орбитального (L) моментов. В РЗЛ атомах или ионах $4f$ -оболочка расположена глубоко внутри атома и экранирована от действия кристалл. поля вышележащими электронными слоями $5s^2$ и $5p^6$.

Среднее межатомное расстояние в Р. м. на порядки величин превышает радиус $4f$ -оболочки. По этим причинам в Р. м. отсутствует заметное перекрытие волновых ф-ций $4f$ -электронов соседних атомов.

Вследствие сильной экранировки $4f$ -оболочки действие электростатич. поля на орбитальный момент $4f$ -оболочки значительно уменьшено, поэтому *«замораживание» орбитальных моментов* выражено весьма слабо. Кроме того, *спин-орбитальное взаимодействие* (характерная энергия $\sim 10^{-1}$ эВ) весьма велико и электростатич. поле окружающих атомов (энергия взаимодействия $\sim 10^{-3}$ эВ) не разрушает спин-орбитальную связь (см. *Связь векторная*). Орбитальный момент, так же, как и спиновый, формирует магн. момент РЗЛ атома. Спиновый S и орбитальный L моменты связаны в результирующий момент J . В осн. состоянии $J = L + S$ для РЗЛ элементов от гадолиния (Gd) до иттербия (Yb), $J = -L - S$ для РЗЛ элементов от церия (Ce) до европия (Eu).

Магнитные свойства РЗЛ металлов обусловлены особенностями электронной структуры их ионов, кристалл. структуры, магнитной анизотропии и обменного взаимодействия.

В большинстве РЗЛ металлов существуют периодич. магнитные атомные структуры, период к-рых довольно часто является несозмеримым с периодом кристалл. решетки. Обменное взаимодействие между РЗЛ ионами является косвенным и осуществляется через электроны проводимости (см. *РККИ-обменное взаимодействие*). Волновой вектор периодич. магн. структур определяется топологией, особенностями ферми-поверхности и близок к диаметрам *де* экстремальных осечей. Магн. структуры и магнитные фазовые переходы зависят также от специфики косвенного обменного взаимодействия и влияния магн. анизотропии и магнитопупругого взаимодействия. В Се обнаружено антиферромагн. упорядочение ниже *Неелл точки* $T_N = 12,5$ К. У неодима (Nd) ниже $T_N = 49,2$ К происходит антиферромагн. упорядочение в гексагональных узлах двойной гексагонально-плотнупакованной решетки с модуляцией величины магн. моментов вдоль оси $[10\bar{1}0]$ в базисной плоскости. Темп-ре $T_N = 7,8$ К соответствует антиферромагн. упорядочение магн. моментов кубич. узлов. Их величина также модулируется по оси $[10\bar{1}0]$. В самарии (Sm) ниже $T_N = 106$ К магн. моменты соседних слоев атомов с гексагональным окружением ориентированы попарно антипараллельно, а при $T_N = 13,8$ К происходит дополнительное антиферромагн. упорядочение магн. моментов кубич. узлов. Имеющий объемноцентрированную решетку Eu обладает ниже $T_N = 90$ К антиферромагн. геликоидальной структурой, ось к-рой является одна из кубич. осей типа $[100]$. В Gd ниже *Кюри точки* $T_C = 293$ К возникает ферромагн. упорядочение. Тербий (Tb), диспрсий (Dy) и гольмий (Ho) обнаруживают две темп-ры магн. фазовых переходов. При охлаждении ниже темп-ры T_N происходит переход из парамагн. состояния в антиферромагн. состояние с геликоидальной магн. структурой, и-рая существует вплоть до темп-ры T_C , где происходит переход

и в ферромагнитном состоянии. В T_D , T_N и T_C оно равен $T_N = 229, 179, 130$ К и $T_C = 220, 53, 19$ К. ферромагнитно равен $T_N = 229, 179, 130$ К и $T_C = 220, 53, 19$ К.

определяют поведение *спин* ферромагнитных металлов, моменты металлов переходят в ферромагнитное состояние при температуре T_N . В ферромагнитном состоянии ферромагнитных металлов происходит упорядочение спинов, моменты металлов переходят в ферромагнитное состояние при температуре T_N . В ферромагнитном состоянии ферромагнитных металлов происходит упорядочение спинов, моменты металлов переходят в ферромагнитное состояние при температуре T_N .

В ферромагнитном состоянии ферромагнитных металлов происходит упорядочение спинов, моменты металлов переходят в ферромагнитное состояние при температуре T_N . В ферромагнитном состоянии ферромагнитных металлов происходит упорядочение спинов, моменты металлов переходят в ферромагнитное состояние при температуре T_N .

$$S = \sum_{m_i \geq 0} \sum_{k_i \geq 0} \dots \times (m_i!)^{-1} \times (k_i!)^{-1} \dots \times a_i^{m_i} \times b_i^{k_i} \dots \times d_i^{p_i} \times e_i^{q_i} \dots$$

В форма предельных случаев:

В форма предельных случаев: $S = \sum_{m_i \geq 0} \sum_{k_i \geq 0} \dots \times (m_i!)^{-1} \times (k_i!)^{-1} \dots \times a_i^{m_i} \times b_i^{k_i} \dots \times d_i^{p_i} \times e_i^{q_i} \dots$

В форма предельных случаев: $S = \sum_{m_i \geq 0} \sum_{k_i \geq 0} \dots \times (m_i!)^{-1} \times (k_i!)^{-1} \dots \times a_i^{m_i} \times b_i^{k_i} \dots \times d_i^{p_i} \times e_i^{q_i} \dots$

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ

Здесь $a^+(\mathbf{p})$, $a^-(\mathbf{k})$ — операторы рождения и уничтожения частиц с импульсами соответственно \mathbf{p} и \mathbf{k} . Для S в нормальной форме (1) вычисление матричного элемента перехода $\langle N|S|M \rangle$ между свободными m -частичным на состоянии $|M\rangle = a^+(\mathbf{p}_m) \dots a^+(\mathbf{p}_1)|0\rangle$, а n -частичным конечным состоянием $\langle N| = \langle 0|a^-(\mathbf{k}_1) \dots a^-(\mathbf{k}_n)$ сводится к использованию квантового интеграла S по n переменным $\delta p_j - k_j$ (они отвечают несвязным Фейнмановским диаграммам).

В релятивистской теории нормальную форму (1) удобно переписать в релятивистски-инвариантном виде, через нормальное произведение свободных полей $\varphi(x)$:

$$S = \sum_{n \geq 0} (n!)^{-1} \langle \Phi_n(x_1, \dots, x_n) | \varphi(x_1) \dots \varphi(x_n) : d^4x_1 \dots d^4x_n \rangle (2)$$

где коеф. разложения Φ_n зависят от пространственно-временных координат x_i . Тогда Р. ф. дается перестановочными соотношениями оператора O , заданного нормальным разложением типа (2), с операторами $a^\pm(\mathbf{p})$:

$$[O, a^\pm(\mathbf{p})] = \pm \Gamma_{\mathbf{p}}^\mp \delta O / \delta \varphi(x) = \pm (2\pi)^{3/2} (2p_0)^{-1/2} \times \int d^4x \exp(\mp i p x) \delta O / \delta \varphi(x) \Big|_{p_0 = \sqrt{p^2 + m^2}} (3)$$

интегральные операции $\Gamma_{\mathbf{p}}^\pm$ осуществляют преобразование Фурье и переводят 4-импульсы $\mathbf{p}(\mathbf{p}_0, \mathbf{p})$ на массовую поверхность: $p^2 = m^2$ (m — масса частицы; используется система единиц, в которой $c = \hbar = 1$). Последоват. выполнение коммутаций a^\pm сначала с S , а затем с её вариант. производными приводит элемент S к неск. эквивалентным формам. Равные формы удобны для выявления следствий разл. аксиом теории; все они используются при исследовании аналитич. свойств амплитуд рассеяния и многочастичных процессов, напр. при доказательстве дисперсионных соотношений в АКТП. В частности, Р. ф.

$$\langle N|S|M \rangle = \Gamma_{\mathbf{k}_1}^- \dots \Gamma_{\mathbf{k}_n}^- \Gamma_{\mathbf{p}_1}^+ \dots \Gamma_{\mathbf{p}_m}^+ G^C(x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) (4)$$

(плюс несвязные вклады) связывает матричный элемент с причинной Грина функцией G^C , через k -ую с помощью преобразования Фурье выражает амплитуда перехода вне массовой поверхности:

$$\int d^4x_1 \dots d^4x_n G^C(x_1, \dots, x_n) \exp\left\{i \sum x_i p_i\right\} = -i(2\pi)^{3/2} \delta\left(\sum p_i\right) \cdot F(p_1, \dots, p_n).$$

В формулировке Лемана — Симанзика — Циммермана (Н. Lehmann, К. Symanzik, W. Zimmermann, 1955) исходным объектом теории служит взаимодействующее (интерполирующее) поле $A(x)$. Асимптотич. состояния при $x_0 = t \rightarrow \pm \infty$ строятся как пределы состояний, полученных действием на вакуум $|0\rangle$ сглаженных операторов:

$$A(f, t) = i \int_{x_0=t} d^3x \left\{ f(x) \frac{\partial A(x)}{\partial x_0} - \frac{\partial f(x)}{\partial x_0} A(x) \right\},$$

где $f(x)$ — гладкие решения Клейна — Гордона уравнения (волновые пакеты),

$$|N_\pm^f\rangle = \lim_{t \rightarrow \pm \infty} A(f_1, t) \dots A(f_n, t) |0\rangle.$$

Теорема Хаага — Рували (R. Haag, D. Ruelle, 1962) утверждает, что в АКТП эти пределы существуют вследствие аксиом Уайтмана. При этом $\langle N_+^f | M_-^g \rangle =$

$$= \langle N_+^f | S | M_-^g \rangle, \text{ а при снятии сглаживания, когда } f(x)$$

становится плоской волной с импульсом p_i и энергией

$$p_0 = \sqrt{p^2 + m^2}, \text{ состояние } |N_+^f\rangle \text{ переходит в } |N\rangle.$$

Р. ф. Лемана — Симанзика — Циммермана связывает фигурирующую в (4) причинную φ -функцию Грина с хронологическим произведением взаимодействующих полей:

$$G^C(x_1, \dots, x_n) = K x_1 \dots K x_n \langle 0 | T(A(x_1) \dots A(x_n)) | 0 \rangle,$$

где $K_{\mathbf{p}} = \square - m^2$ ($\square = \Delta$ — Даламберта оператор).

Лит.: Швобер С., Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, пер. с англ., М., 1965; Ицксон К. Г., Зиббер Ж.-В., Квантовая теория поля, пер. с англ., т. 1, М., 1984; Богдолов Н. Н., Догунов А. А., Ойскан А. Н., Тодоров И. Т., Общие принципы квантовой теории поля, М., 1987. В. Н. Павлов.

РЕДУЦИРОВАННЫЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ (наз. также **эффективными**) — характеризуют оптическое излучение по его воздействию на заданный селективный приёмник. При любом спектральном составе излучения одинаковым реакциям селективного приёмника соответствуют равные значения Р. ф. в. В этом их основное удобство, особенно при оценке излучения, применённого в практич. целях. Каждая из Р. ф. в. есть интеграл от произведения **спектральной плотности** соответствующей энергии, величины, характеризующей излучение, на **спектральную чувствительность** данного приёмника. В систему СИ из Р. ф. включены только **световые величины**. Д. Н. Захарев, **РЕЗЕРФОРД** (Рд, Rd) — внесистемная единица активности нуклидов в радиоактивных источниках. Названа в честь Э. Резерфорда (E. Rutherford). 1 Рд равен активности изотопа, в k -ром за 1 с происходит 10^6 распадов, т. е. 1 Рд = 10^6 Бк = $1/37000$ юри. **РЕЗЕРФОРДА ФОРМУЛА** — формула для эффективного сечения рассеяния нерелятивистских заряд. точечных частиц, взаимодействующих по закону Кулона; получена Э. Резерфордом (E. Rutherford) в 1911. В системе центра инерции сталкивающихся частиц Р. ф. имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{2m v^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} (5)$$

где $d\sigma/d\Omega$ — сечение рассеяния в единичный телесный угол, θ — угол рассеяния, $m = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ — приведённая масса, m_1, m_2 — массы сталкивающихся частиц, v — их относит. скорость, $Z_1 e, Z_2 e$ — электрич. заряды частиц (e — элементарный электрич. заряд). Р. ф. справедлива как в классич., так и в квантовой теории. Ф-ла (5) была использована Резерфордом при интерпретации опытов по рассеянию α -частиц тонкими металлич. пластинками на большие углы ($\theta > 90^\circ$). В результате анализа опытных данных он пришёл к выводу, что почти вся масса атома сконцентрирована в малом положительн. заряд. ядре. Этим открытием были заложены основы совр. представлений о строении атомов. С. М. Вильямс.

РЕЗОНАНС (франц. resonance, от лат. resono — откликаться) — частотно-избирательный отклик колебат. системы на периодич. внеш. воздействие, при k -ром происходит резкое возрастание амплитуды стационарных колебаний. Наблюдается при приближении частоты внеш. воздействия к определённым, характерным для данной системы значениям. В линейных колебат. системах число таких резонансных частот соответствует числу степеней свободы и они совпадают с частотами **собственных колебаний**. В нелинейных колебат. системах, реактивные в диссипативные параметры k -рых зависят от величин стороннего воздействия, Р. м. может проявляться и как отклик на внеш. силовое воздействие, и как реакция на периодич. изменение параметров. В **узком** значении термин «Р.» относится лишь к случаю **силового воздействия**.

Резонанс в линейных системах с одной степенью свободы. Пример простейшего случая Р. представляють

вынужденные колебания, возбуждаемые сторонним источником — гармонической эдс $\sim E_0 \cos pt$ с амплитудой E_0 и частотой p — в колебательном контуре (рис. 1, а). Амплитуда x и фаза φ вынужденных колеба-

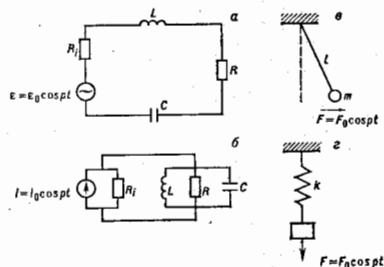


Рис. 1. Колебательные системы с одной степенью свободы: последовательный (а) и параллельный (б) колебательные контуры, математический маятник (в) и упругий осциллятор (г).

ний ряда $[q(t) = x \cos(pt + \varphi)]$ определяются амплитудой и частотой внеш. силы:

$$x = \frac{F}{\sqrt{(\omega_0^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{2\delta p}{\omega_0^2 - p^2}, \quad (1)$$

где $F = E_0/L$, $\delta = (R + R_i)/2L$.

Зависимость амплитуды x стационарных вынужденных колебаний от частоты p вынуждающей силы при постоянной её амплитуде наз. резонансной кривой (рис. 2). В линейном колебат. контуре резонансные кривые, соответствующие различным F , подобны, а фазово-частотная характеристика $\varphi(p)$ не зависит от амплитуды силы.

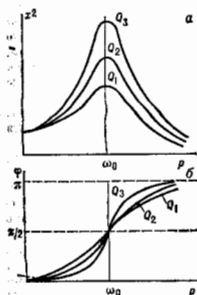


Рис. 2. Резонансные кривые (а) и фазово-частотные характеристики (б) колебательных контуров при разных значениях добротности, $Q_1 < Q_2 < Q_3$.

Уменьшение амплитуды вынужденных колебаний при точной настройке обусловлено нарушением синфазности тока и напряжения в цепи.

Важной характеристикой резонансных свойств колебат. системы (осциллятора) является добротность Q , т.е. по определению, равна умноженному на 2π отношению энергии, запасённой в системе, к энергии, рассеиваемой за период колебаний. При воздействии на резонансной частоте амплитуда вынужденных колебаний x в Q раз больше, чем в квазистатич. случае,

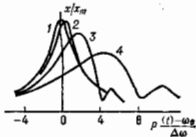
при $p \ll \omega_0$ ($x = QF$). Число периодов колебаний, в течение к-рых происходит установление стационарной амплитуды, также пропорц. Q . Наконец, добротность определяет частотную избирательность резонансных систем. Ширина полосы $\Delta\omega$, в пределах к-рой амплитуда вынужденных колебаний падает в $\sqrt{2}$ раз от x , обратно пропорц. добротности: $\Delta\omega = \omega_0/Q = 2\delta$.

При P в электрич. цепях реактивная часть комплексного импеданса обращается в нуль. При этом в последоват. цепи падения напряжения на катушке индуктивности и на конденсаторе имеют амплитуду QE_0 . Однако они складываются в противофазе и взаимно компенсируют друг друга. В параллельной цепи (рис. 1, б) при P происходит взаимная компенсация токов в ёмкостной и индуктивной ветвях. В отличие от последоват. P , при к-ром внеш. силовое воздействие осуществляется источником напряжения, в параллельном контуре резонансные явления реализуются только в том случае, когда внеш. воздействие является источником тока. Соответственно P в последоват. контуре называют P . напряжений, а в параллельном контуре — P . токов. Если в параллельный контур вместо генератора тока включить генератор напряжения, то на резонансной частоте будут выполняться условия не максимума, а минимума тока, поскольку вследствие компенсации токов в ветвях, содержащих реактивные элементы, проводимость цепи оказывается минимальной (явление антирезонанса).

Подобными чертами обладает явление P в механич. и др. колебат. системах. В линейных системах, согласно принципу суперпозиции, реакцию системы на периодич. несинусоидальное воздействие можно найти как сумму откликов на каждую из гармоник компонент воздействия. Если период несинусоидальной силы равен T , то резонансное возрастание колебаний может происходить не только при условии $\omega_0 \approx 2\pi/T$, но в зависимости от формы $E(t)$ и при условиях $\omega_0 \approx 2\pi n/T$, где $n = 1, 2, \dots$ (P за гармониками).

Резонансные кривые определяют, наблюдая изменение амплитуды вынужденных колебаний либо при медленной перестройке частоты p вынуждающей силы, либо при медленном изменении собств. частоты ω_0 . При высокой добротности осциллятора ($Q \gg 1$) оба способа дают практически одинаковые результаты. Частотные характеристики, полученные при конечной скорости изменения частоты, отличаются от статич. резонансных кривых, соответствующих бесконечно медленной перестройке: на динamicaх частотных характеристиках наблюдается смещение максимума в направлении перестройки частоты, пропорц. μ , где $\mu = t/t^*$, $t^* = Q/\omega_0$ — время релаксации колебаний в контуре,

Рис. 3. Статические и динамические амплитудно-частотные характеристики резонанса при различных скоростях изменения частоты: $p(t) = \omega_0 + t/t^*$, $\mu = 0(1)$, $0,0625(2)$, $0,25(3)$, $0,505(4)$.



t^* — время, в течение к-рого частота p находится в пределах полосы резонанса $\Delta\omega$. При быстрой перестройке частоты, по мере роста μ , происходит уменьшение высоты и расширение резонансных кривых, причём их форма становится более асимметричной (рис. 3).

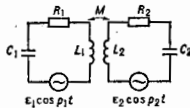
Резонанс в линейных колебательных системах с несколькими степенями свободы. Колебат. системы с неск. степенями свободы представляют собой совокупность взаимодействующих осцилляторов. Примером может служить пара колебат. контуров, связанных за счёт взаимной индукции (рис. 4). Вынужденные колебания в такой системе описываются ур-ниями

$$L_1 \ddot{q}_1 + M \ddot{q}_2 + R_1 \dot{q}_1 + C_1^{-1} q_1 = E_1 \cos p_1 t, \quad (2)$$

$$L_2 \ddot{q}_2 + M \ddot{q}_1 + R_2 \dot{q}_2 + C_2^{-1} q_2 = E_2 \cos p_2 t.$$

Индуктивная связь приводит к тому, что колебания в одних контурах не могут происходить независимо друг от друга. Однако для любой колебат. системы с нек.

Рис. 4. Колебательная система с двумя степенями свободы — пара контуров со связью за счёт взаимоиндукции.



степенями свободы можно найти нормальные координаты, к-рые являются линейными комбинациями независимых переменных. Для нормальных координат система у-рний, подобная (2), преобразуется в цепочку у-рний для вынужденных колебаний такого же вида, как для одиночных колебат. контуров, с тем отличием, что воздействие на каждую из нормальных координат оказывают силы, приложённые, вообще говоря, в разных частях совокупной колебат. системы. При рассмотрении законов движения в нормальных координатах справедливы все закономерности Р. в системах с одной степенью свободы.

Резонансное нарастание колебаний происходит во всех частотах колебат. системы на одних и тех же частотах (рис. 5), равных частотам собств. колебаний системы. Нормальные частоты не совпадают с парциальными, т. е. с собств. частотами осцилляторов, входящих в совокупную систему. Если частота сторонней силы равна одной из парциальных частот, то в совокупной системе Р. не наступает. Напротив, в этом случае амплитуды вынужденных колебаний достигают минимума, аналогично случаю антирезонанса в системе с одной степенью свободы. Возможность подавления колебаний, частота к-рых равна одной из парциальных, используется в электрич. фильтрах и успокоителях механич. колебаний.

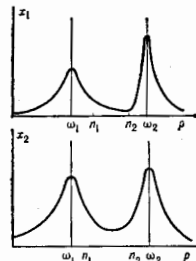


Рис. 5. Резонансные кривые для системы с двумя степенями свободы при силовом воздействии $e_1 \neq 0, e_2 = 0; \omega_1, \omega_2$ — нормальные частоты; ν_1, ν_2 — парциальные частоты.

В системе, состоящей из слабо связанных осцилляторов с одинаковыми парциальными частотами, резонансные максимумы, отвечающие близким нормальным частотам, могут сливаться, так что частотная характеристика имеет один максимум (рис. 6). Увеличение связи

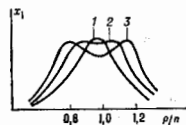


Рис. 6. Резонансные кривые двухконтурной колебательной системы при $\gamma Q = 1(1), \sqrt{2}(2)$ и $2(3); \gamma = M/L, L_1 = L_2$.

между осцилляторами приводит к росту интервала между нормальными частотами системы. Изменение формы резонансных кривых при увеличении коэф. связи иллюстрирует рис. 6. Система осцилляторов при связи, близкой и критической, имеет частотную характеристи-

ку, уподобленную близки Р., причём крутизна её склонов выше, чем у одиночного осциллятора с таким же уровнем потерь. Это свойство обычно используется при создании полосовых электрич. фильтров.

Резонанс в распределённых колебательных системах. В распределённых системах (см. Система с распределёнными параметрами) амплитуда и фаза колебаний зависят от пространственных координат. Линейные распределённые колебат. системы характеризуются набором нормальных частот и собств. ф-ций, к-рые описывают пространственное распределение амплитуд собств. колебаний. Резонансные свойства (добротность) распределённых систем определяются не только собств. затуханием, но и связью с окружающей средой, в к-рую происходит вылучение части энергии колебаний (электрич., упругих и др.). В распределённых системах, обладающих высокой добротностью ($Q \gg 1$), вынужденные колебания представляют собой стоячие волны, пространственное распределение амплитуд к-рых является суперпозицией собств. ф-ций (мод), а фаза колебаний одинакова во всех точках. Действие сторонних сил с частотами, близкими к собственным, ведёт к резонансному нарастанию амплитуды вынужденных колебаний во всех точках объёма распределённой резонансной системы (резонатора).

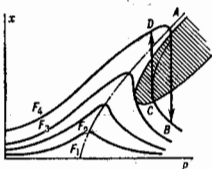
В распределённых системах сохраняют силу все общие свойства Р. Особенностью Р. в распределённых системах (равно как и в системах с нек. степенями свободы) является зависимость амплитуд вынужденных колебаний не только от частоты, но и от пространственного распределения вынуждающей силы. Р. наступает, если пространственное распределение внеш. силы повторяет форму собств. ф-ции, а частота равна соответствующей нормальной частоте. При неблагоприятном пространственном распределении сторонней силы вынужденные колебания не возбуждаются. Это происходит, в частности, тогда, когда сосредоточенная сила прикладывается в точках, для к-рых амплитуда соответствующего нормального колебания обращается к нулю. Так, прикладывая сосредоточенную силу в точке, являющейся узловой для перемещений струны, невозможно возбудить её колебания, поскольку работа силы будет равна нулю. Если распределение сил таково, что работа, совершаемая ими в разл. частях системы, имеет противоположные знаки и в целом не приводит к изменению энергии, вынужденные колебания также не возбуждаются.

Резонанс в нелинейной колебательной системе. В упругих системах нелинейным элементом является пружина, для к-рой связь между деформацией и упругой силой нелинейна, т. е. нарушается закон Гука. В электрич. системах примером нелинейного диссипативного элемента является диод, вольт-амперная характеристика к-рого не подчиняется закону Ома. Нелинейными реактивными (энергетическими) элементами являются конденсаторы с сегнетоэлектриком или итертими индуктивностями с ферритовыми сердечниками. Параметры этих элементов — ёмкость, индуктивность, сопротивление, а также собств. частоту и коэф. затухания в нелинейных системах можно считать ф-циями тока или напряжения. При этом в нелинейных системах не выполняется суперпозиции принцип.

В нелинейных системах гармонич. сила возбуждает негармонич. колебания, в спектре к-рых имеются кратные частоты, поэтому Р. на гармониках происходит и при синусоидальной внеш. силе. В колебат. системах, обладающих достаточно высокой добротностью и частотной избирательностью, наиб. амплитуду имеет их спектральная компонента, частота к-рой близка к частоте Р. Рассматривая лишь колебания с частотой, близкой и резонансной, можно и в этом случае получить семейство резонансных кривых. Для системы с нелинейными реактивными (энергетическими) элементами при $p \approx \omega_0$ эти кривые изображены на рис. 7. Форма резонансной кривой зависит от амплитуды вынуждающей

силы в по мере её увеличения становится всё более асимметричной. Поскольку частота собств. колебаний нелинейного осциллятора зависит от её амплитуды, то и максимумы на резонансных кривых сдвигаются в сторону более высоких или более низких частот. Начиная с некоего значения амплитуды силы, резонансные кривые приобретают неоднозначную кривообразную форму. В определённом интервале частот стационарная амплитуда вынужденных колебаний оказывается зависящей от предельной установки колебаний (явление колеб. гистерезиса). При этом части резонансных кривых, соответствующих неустойчивым

Рис. 7. Семейство амплитудно-частотных кривых в случае нелинейного резонанса при различных амплитудах сторонней силы ($F_1 < F_2 < F_3 < F_4 < F_5$). Пунктир — неустойчивый участок резонансной кривой. Затрихована область неустойчивых состояний. Стрелками отмечены точки скачкообразного изменения амплитуд колебаний при перестройке частоты вверх (АВ) и вниз (СD).



состояниям, образуют на плоскости (x, p) область фазических эргодических режимов (на рис. 7 затрихована).

На явление нелинейного Р. в распротранённых колебл. системах могут оказать существ. влияние эффекты самофокусирования и образования ударных волн, особенно в тех случаях, когда на длине резонатора укладывается большое число волн.

Явления, родственные резонансу. В нелинейных колебл. системах внеш. периодич. воздействие вызывает не только возбуждение вынужденных колебаний, но и модуляцию энергетич. и диссипативных параметров. Явление возбуждения колебаний при периодич. модуляции энергетич. параметров наз. параметрич. резонансом.

Если глубина модуляции энергетич. параметра недостаточна для возбуждения параметрич. Р., в колебл. системе происходит частичное восполнение потерь. Резонансный отклик на действие слабого сигнала с частотой $p \approx \omega_0$ при этом такой же, как у линейного осциллятора с более высокой добротностью. Кроме того, образуются колебания комбинац. частот $m\omega_0 + n\omega_0$, где ω_0 — частота модуляции параметра, $m, n = \pm 1, \pm 2, \dots$ При совпадении частоты p и $(\omega_0 - p)$ вынужденные колебания в параметрически регенерированной системе зависят от соотношений между фазами параметрич. воздействия и слабой силы (сигнала). При этом может происходить как увеличение, так и уменьшение амплитуд вынужденных колебаний по сравнению с отсутствием параметрич. регенерации (явления «сильного» и «слабого» Р.).

Эффект регенерации потерь и повышения эквивалентной добротности имеет место в резонансных системах с величинными потерями, к-рые содержат элементы с отрицательными дифференциальными сопротивлениями или цепи положительной обратной связи. Такие системы наз. потенциально автоколебл. системы. Если на потенциально автоколебл. систему воздействует периодич. сила значит. амплитуды с частотой p , она может влиять на затухание колебаний в системе так, что в течение определенной доли периода действия силы затухания оно становится отрицательным. В результате в потенциально автоколебл. системе возбуждаются колебания на частоте ω , близкой к собственной, если дополнительно выполнено условие $\omega = p/n$. Случай $l = 1$ отвечает спярконаизации частоты автоколебаний внеш. силой. При $l \geq 2$ данное явление носит наз. автопараметрич. возбуждения, но аналогия с параметрическим резонансом, в отличие от к-рого при автопараметрич. возбуждении происходит модуляция не энергетич., а диссипативных параметров системы.

Термин «Р.» употребляется и по отношению к процессам в квантовых системах, когда частота внеш. воздействия (излучения) равна частоте квантового перехода, так что выполняется условие

$$h\nu = \epsilon_n - \epsilon_m, \quad (3)$$

где ϵ_n, ϵ_m — энергия соответственно n -го, m -го уровней квантовой системы. При выполнении (3) резко возрастают вероятности квантовых переходов, что проявляется как увеличение интенсивности обмена энергией — поглощения и излучения (см. *Квантовая электроника. Лазер*).

Р. может быть причиной неустойчивости и разрушительной механик. инженерных конструкций и электр. сетей. В вибропреобразователях Р. позволяет достигать значит. амплитуд упругих колебаний благодаря периодич. действию сравнительно слабой силы. В радиотехнике и радиотехнике явление Р. лежит в основе мн. способов фильтрации сигналов разных частот, обнаружения и приёма слабых сигналов.

Лит.: Горелкич Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959; Стрелков С. П., Введение в теорию колебаний, 2 изд., М., 1964; Харкевич А. А., Избр. труды, т. 2, М., 1973; Основы теории колебаний, под ред. В. В. Митупина, 2 изд., М., 1988.

РЕЗОНАНСНАЯ КОНВЕРСИЯ НЕЙТРИНО — гипотетич. процесс перехода одного типа нейтрино в другой при распространении в среде с монотонно изменяющейся плотностью. Переход осуществляется непрерывно, в соответствии с вариациями плотности и в осн. при пересечении слоя с т. п. резонансной плотностью. Необходимым условием Р. к. в. является смешивание нейтрино, участвующих в конверсии. Возможность Р. к. в. была показана С. П. Михеевым и А. Ю. Смирновым в 1985 [1], при этом использовались результаты Л. Вольфштайна [2] 1978—80 по осцилляциям нейтрино в веществе с пост. плотностью (в литературе Р. к. в. часто называют МСВ-эффектом, по именам Михеева, Смирнова, Вольфштайна).

Условия резонансной конверсии нейтрино. Необходимым условием конверсии нейтрино, напр. $\nu_e \leftrightarrow \nu_\mu$, является смешивание этих нейтрино, т. е. наличие взаимодействия, переводящего ν_e в ν_μ . В случае вакуумного смешивания это недиагональные массовые члены, так что ν_e и ν_μ оказываются когерентными смесями двух состояний ν_1 и ν_2 с определенными массами m_1 и m_2 :

$$\begin{aligned} |\nu_e\rangle &= \cos\theta |\nu_1\rangle + \sin\theta |\nu_2\rangle, \\ |\nu_\mu\rangle &= \cos\theta |\nu_2\rangle - \sin\theta |\nu_1\rangle, \end{aligned} \quad (1)$$

где θ — вакуумный угол смешивания (см. *Осциллирующие элементарных частиц*).

Конверсия в веществе обусловлена рефракцией — упругим рассеянием нейтрино в среде на нулевой угол, к-рое приводит к появлению у волн нейтрино показателей преломления $n_e, n_\mu, (n - 1) \approx G_F N/k$ (G_F — константа Ферми, N — концентрация частиц среды, $k = |k|$, k — импульс нейтрино). Среда влияет на эволюцию смешанных нейтрино, если n_e и n_μ различны. Это влияние определяется длиной рефракции l_0 — расстоянием, на к-ром догонит. разность фаз между волнами ν_e и ν_μ , возникающая вследствие рассеяния, становится равной 2π [2]:

$$l_0 = 2\pi/k(n_e - n_\mu).$$

Для $\nu_e - \nu_\mu$ -системы в обычной среде различие n_e и n_μ возникает из-за рассеяния ν_e на электронах за счёт заряженных токов:

$$l_0 = 2\pi/k(n_e - n_\mu) = 2\pi/\sqrt{2} G_F N_e$$

(N_e — концентрация электронов).

Среда изменяет смешивание ν_e и ν_μ , к-рое определяется [аналогично (1)] относительно $|\nu_{1m}\rangle$ — собств. состояний гамильтониана для данной среды (с учётом взаимодействия). Состояния $|\nu_{1m}\rangle$ являются аналогами $|\nu_i\rangle$ в среде. Угол смешивания в среде θ_m , связываю-

щий v_e , v_a с v_{im} , v_{am} , не равен θ и является ф-цией плотности среды $\rho \approx m_N N_0 (m_N - \text{масса нуклона})$, а также энергии нейтринно \mathcal{E} . Зависимость параметра смешивания $\sin^2 2\theta$ от ρ (а также от \mathcal{E}) имеет резонансный характер (рис. 1, а). При т. н. резонансной плотности

$$m_N(N_e)_R = \rho_R = \frac{\Delta m^2 \cos(2\theta)_{m_N}}{2\sqrt{2} G_F \mathcal{E}} \quad (2)$$

($\Delta m^2 = m_a^2 - m_s^2$) $\sin^2 2\theta_{m_N}$ достигает максимума — единицы. Смешивание в резонансе при произвольно малом θ становится максимальным. Полуширина резонанса равна $\Delta\rho_R = \rho_R \tan 2\theta$. Величины ρ_R и $\Delta\rho_R$ определяют резонансный слой $\rho_R \pm \Delta\rho_R$, где в осн. и происходит конверсия.

В резонансе $l_e = l_s \cos 2\theta$ ($l_e = 2R\mathcal{E}/\Delta m^2$ — вакуумная длина осцилляций), т. е. резонанс при малых θ соответствует равенству «совств. периода» системы l_e и «периода» l_s , характеризующего внеш. среду. Как отметили Н. Кабиббо (N. Cabibbo) и независимо Х. Бетэ [3], в резонансе сравниваются энергии состояний $|v_e\rangle$ и $|v_a\rangle$ (происходит *пересечение уровней*); при этом расщепление спектра значений гамма-ловнана \mathcal{E}_{im} , т. е. энергий состояний $|v_{im}\rangle$, становится минимальным (рис. 1, б).

Динамика конверсии нейтринно в среде основывается на изменении *ароматов* (при распространении в неоднородной среде), т. е. v_e и v_a -состава *собств. состояний* и на

слабом изменении или постоянстве примесей *самых* $|v_{im}\rangle$ в данном нейтринном состоянии. Аромат $|v_{im}\rangle$ определяется углом смешивания θ_m аналогично (1). При уменьшении ρ от $\rho \gg \rho_R$ до $\rho \ll \rho_R$ угол смешивания θ_m уменьшается от $\approx \pi/2$ до $\approx \theta$ и соответственно, если θ мал, аромат v_{im} меняется практически полностью (у v_{im} , напр., от $\approx v_e$ до $\approx v_a$). Это изменение происходит в осн. в резонансном слое. Вариации примесей $|v_{im}\rangle$ в данном состоянии $|v(t)\rangle$ контролируются условием адиабатичности, к-рое устанавливает верхний предел на скорость изменения плотности с расстоянием $d\rho/dr$. Если условие адиабатичности выполнено (ρ изменяется медленно), то вероятности переходов между *собств. состояниями* преобладающе малы и примеси $|v_{im}\rangle$ в $|v(t)\rangle$ сохраняются.

Конверсия в среде, переходы в разных режимах. Р. н. в. — это по существу изменение аромата нейтринного состояния при адиабатическом (или слабо неадиабатическом) пересечении резонансного слоя. В зависимости от нач. условий и характера распространения нейтринно выделяются 3 типа переходов.

Безосцилляционный переход реализуется, когда нейтринно возникает при $\rho \gg \rho_R$ и распространяется адиабатически. В этом случае нейтринное состояние $|v(t)\rangle$, рождаемое как $|v_e\rangle$, $|v(0)\rangle = |v_e\rangle$, будет практически совпадать с $|v_{am}\rangle$ и это совпадение сохранится в силу адиабатичности в процессе всей эволюции. Если ρ уменьшается до $\rho \ll \rho_R$, то $|v_{am}\rangle$, а вместе с ним и $|v(t)\rangle$ изменят аромат практически полностью. Вероятно

обнаружить v_a на выходе (вероятность выживания) $P = \sin^2 \theta$ (рис. 2).

Осцилляционный адиабатический переход реализуется, когда адиабатичность выполнена, но нейтринно рождаются близко к резонанс-

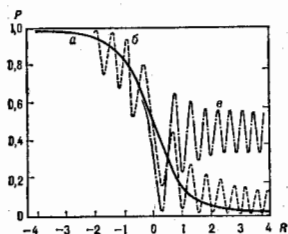


Рис. 2. Пространственная карта резонансной конверсии. Зависимость вероятности выживания от расстояния до резонансного слоя для безосцилляционного (сплошная линия), осцилляционного адиабатического (штриховая линия) и неадиабатического (штрих-пунктирная линия) переходов. Резонанс реализуется при $R = 0$; интервал $R = (-1; 1)$ соответствует резонансному слою.

ному слою или в самом резонансном слое. В этом случае нейтринное состояние содержит сравнимые примеси *собств. состояний*, причём в силу адиабатичности эти примеси будут сохраняться. Наличие примесей $|v_{im}\rangle$ в $|v(t)\rangle$ приводит к осцилляциям. Осцилляции накладываются на конверсию (рис. 2), однако ср. значение вероятности будет изменяться в соответствии с величиной плотности [см. ниже ф-лу (3) с $P_{21} = 0$].

Неадиабатический переход. Примеси *собств. состояний* изменяются. Даже если в нач. момент $|v\rangle$ совпадало с $|v_{am}\rangle$, то в процессе распространения с нек-рой вероятностью P_{21} в нём появится примесь $|v_{im}\rangle$. Ср. вероятность выживания при этом имеет вид

$$P = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - P_{21}\right) \cos 2\theta_m^0 \cos 2\theta_m(\rho), \quad (3)$$

где θ_m^0 — угол смешивания в точке рождения. С ростом P_{21} конверсия ослабляется (рис. 2) [4].

Р. н. в. аналогична многим известным явлениям в разных областях физики [5] — передаче колебаний в системе связанных маятников, повороту спина электрона во вращающемся магн. поле, переходам между уровнями атомов и молекул под действием внеш. возмущения и др.

Обобщения. Типы резонансной конверсии. Условия резонансной конверсии — смешивание, резонанс (пересечение уровней), адиабатичность — имеют ряд разл. реализаций. В зависимости от свойств нейтринных состояний, к-рые смешиваются, выделяют 3 типа конверсии. При т. н. ф-лэверной конверсии (от англ. flavor — аромат), обсуждавшейся выше, измеряется аромат нейтринного состояния, во не является *спиральность*. В общем случае смешиваются 3 типа нейтринно v_e, v_μ, v_τ , и такая система обладает 3 резонансами. Если массы m_1, m_2, m_3 достаточно сильно различаются, так что резонансы разделены на шкале плотностей, то их прохождение можно рассматривать независимо: трёхнейтринной конверсии сводится к двухнейтринной. Спиральная конверсия реализуется между левой (v_L) и правой (v_R) компонентами дираковского нейтринно ($v_L \rightarrow v_R$). Смешивание v_L и v_R обусловлено взаимодействием магн. момента нейтринно μ , с магн. полем. Как распределение уровней, так и их пересечение связаны с рефракцией в неоднородной среде. При спин-флэверной конверсии

меняются в аромат, и спиральной нейтринного состояния, напр. $\nu_{eL} \rightarrow \nu_{eR}$ (где ν_{eL} и ν_{eR} соответственно левое и правое нейтрино и правое мюонное антинейтрино). Смешивание вызвано взаимодействием т. н. недиагонального магн. момента нейтрино с магн. полем. Расщепление уровней обусловлено различием в массах и взаимодействиях ν_{eL} с веществом [6]. Разные типы конверсии отличаются зависимостями эффектов от энергии нейтрино.

Приложения. Области возможных приложений Р. к и. н. — нейтринная астрофизика и геофизика — определяются тем, что толща d вещества, проходящая нейтрино, должна быть достаточно большой: $d \geq d_0 \approx \rho l_0 \approx m_N / G \approx 3 \cdot 10^6 / G$ см. Условия конверсии выполняются в широких интервалах Δm^2 и $\sin^2 2\theta$ (несколько порядков величин) на Солнце и в коллапсирующих звездах. Осн. эффекты конверсии в среде — подавление потока нейтрино исходного типа (соответственно появление потоков нейтрино новых типов) и искажение энергетич. спектра нейтрино, зависящее определенным образом от Δm^2 и $\sin^2 2\theta$.

Приложения имеют 3 следующих аспекта. Во-первых, поскольку конверсия изменяет свойства потоков нейтрино, её возможные эффекты следует иметь в виду при интерпретации наблюд. данных нейтринной астрономии. В частности, конверсия может решить проблему солнечных нейтрино. Во-вторых, если профиль плотностей и исходный спектр нейтрино известны, то, измеряя искажение спектра, можно в принципе определить Δm^2 и $\sin^2 2\theta$. Р. к и. н. открывает уникальные возможности, т. к. сильные изменения в лучках возникают даже при очень малых значениях параметров смешивания и Δm^2 , не достижимых обычным экспериментам. Если эффекты конверсии не будут обнаружены, это позволит исключить область параметров Δm^2 и $\sin^2 2\theta$, namely, переключившую область чувствительности существующих и планируемых лаб. экспериментов. Наконец, если Δm^2 и $\sin^2 2\theta$ известны, то по эффектам конверсии можно судить о распределении плотностей вещества на пути нейтрино.

Лит.: 1) М и х е в С. П., С м и р н о в А. Ю., Резонансное усиление осцилляций в веществе и спонтанности солнечных нейтрино, «Ядерная физика», 1985, т. 42, в. 6, с. 1444; и х же, Осцилляция нейтрино в среде с переменной плотностью и усиления от гравитационных коллапсов звезд, «ЭТФ», 1986, т. 91, с. 7; 2) W o l f e n b e r g L., Neutrino oscillations in matter, «Phys. Rev. D.», 1978, в. 17, p. 2369; е го же, Neutrino oscillations and stellar collapse, «Phys. Rev. D.», 1979, в. 20, p. 2634; 3) B e t h e H., Possible explanation of the Solar-Neutrino puzzle, «Phys. Rev. Lett.», 1986, в. 56, p. 1308; 4) F r a n k e S. J., Nonadiabatic level crossing in resonant neutrino oscillations, «Phys. Rev. Lett.», 1986, в. 57, p. 1275; 5) М и х е в С. П., С м и р н о в А. Ю., Резонансные осцилляции нейтрино в веществе, «ФДН», 1987, т. 153, с. 5; 6) А х м е д о в Е. Х., Б е ч у к О. В., Резонансная спи-флевиновая прецессия нейтрино и проблема солнечных нейтрино, «ЭТФ», 1988, т. 95, с. 442. А. Ю. Смирнов.

РЕЗОНАНСНАЯ ЛИНИЯ — спектральная линия атома, для к-рой частота испускаемого света совпадает с частотой излучения, поглощаемого атомом в осн. состоянии. Обычно термин «Р. л.» применяют к одной

или нескольким набр. интенсивным линиям, соответствующим разрешенным оптич. переходам (электрич. дипольным переходам) между осн. состоянием и набр. являю деками возбужденными уровнями энергии (рис.). Р. л. атомов большинства элементов расположено в видимой и УФ-областях спектра. Напр., длины волн Р. л. атомов Н, He, Na и Hg соответственно равны (в нм): 121,568; 58, 4328; 588,995/589, 593; 253,652/184, 950. Р. л. атомов Cs и Fr расположены в ближней ИК-области спектра.

Лит. см. при ст. Спектральная линия.

Е. А. Южов.

РЕЗОНАНСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (резонансная флуоресценция, резонансное рассеяние, резонансная люминесценция) — фотолуминесценция, при к-рой частота возбуждающего излучения ω_0 практически совпадает с частотой фотолуминесценции атома $\omega = (\epsilon_2 - \epsilon_1)/h$, где ϵ_2 и ϵ_1 — энергии верхнего возбужденного и нижнего (обычно основного) уровней энергии атома. Р. и впервые обнаружено в 1904 Р. Вудом (R. Wood) в парах натрия.

Р. и на атоляр. атоме по существу есть *релеево*е рассеяние света, усиленное благодаря резонансу на много порядков величин. Спектр Р. и неподвижного изолатора, атома зависит от спектра возбуждающего излучения. При возбуждении его излучением непрерывного спектра шириной $\Delta\omega \gg \gamma_{\text{еф}}$, где $\gamma_{\text{еф}}$ — естественная ширина спектральной линии данного атома, линия Р. и имеет лоренцевский спектр с шириной $\gamma_{\text{еф}}$ (см. Контур спектральной линии), т. е. такой же, что и при возбуждении атома др. способом (напр., столкновительным). Если атом возбуждается монохроматич. излучением, то его Р. и является также монохроматическим и имеет ту же частоту ω_0 (с точностью до эффектов отдачи). При этом, если осн. состояние атома не вырождено, то падающая волна и волна Р. и когерентны.

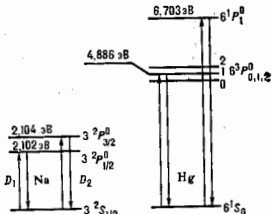
В разреженном газе контур линии Р. и определяется доплеровским уширением спектральных линий и его ширина зависит от угла рассеяния. Если спектральная линия атома испытывает доплер. уширение Γ и сдвиг Δ за счёт соударений, а Р. и возбуждается монохроматич. излучением, то спектр Р. и состоит из излучения той же частоты ω_0 и лоренцевского контура с максимумом на частоте $\omega_0 + \Delta$ и с шириной $\Gamma + \gamma_{\text{еф}}$. В том случае, когда столкновение приводит лишь к сдвигу фазы волновой ф-ции атомного состояния, отношение интенсивностей этих компонент Р. и равно $\gamma_{\text{еф}}/\Gamma$. При наличии неупругих столкновений отношение интенсивностей будет другим и в спектре Р. и возможно появление доплер. линий.

Обычно Р. и поляризовано. В общем случае степень поляризации и её характер определяются поляризацией возбуждающего излучения, направлением возбуждения по отношению к направлению распространения возбуждающей волны, давлением и составом излучающего газа, ориентацией и величиной веш. электр. и магн. полей. Особенно сильно на поляризацию влияет магн. поле (см. Зеемана эффект).

При возбуждении Р. и излучением высокой интенсивности резонансная спектральная линия расщепляется, а также происходят и др. изменения спектра, зависящие от статистич. свойств возбуждающего излучения.

Лит.: В у д Р., Физическая оптика, пер. с англ., Л.—М., 1936; М и т ч е л А., Земаанский М., Резонансное излучение в возбужденных атомах, пер. с англ., М.—Л., 1937; Г а й т л е р В., Квантовая теория излучения, пер. с англ., 12 изд., М., 1956; П р и н г е р с е й м П., Флуоресценция и фосфоресценция, пер. с англ., М., 1954; В е р е с т е н ц и В. Б., Л и ф ш и н Е. М., П и т е в с к и й Л. П., Квантовая электродинамика, 3 изд., М., 1989; А х м е д о в Е. Х., В о р с т е л и н В. В., Квантовая электродинамика, 4 изд., М., 1981; Л о у д о н Р., Квантовая теория света, пер. с англ., М., 1976; S w a i n S., Theory of atomic processes in strong resonant electromagnetic fields, в сб.: Advances in atomic and molecular physics, в. 18, N. Y.—L.—Toronto, 1980, p. 159. Е. А. Южов.

РЕЗОНАНСНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ — процессы, для к-рых характерна резкая немонотонная зависи-



Схемы изомолекулярных уровней энергии и резонансные квантовые переходы Na (желтый дублет D_1 и D_2) и Hg.

мость эфф. сечения от энергий бомбардирующих частиц. Для сечений мн. ядерных реакций и процессов рассеяния микростаян характерно наличие острых резонансов. Это связано с существованием квази стационарных (метастабильных) состояний в промежуточных составных системах, время жизни k -рых заметно больше времени пролета частицы через ядро (см. Составное ядро). Стабильность таких квази стационарных состояний в условиях, когда возможно («открыто») много каналов распада, обусловлена кулоновскими и центробежными барьерами, задерживающими процессы распада, а также сложностью внутр. структуры. Вероятности образования конфигураций, связанных с каналами распада, для таких структур оказываются малыми. О. Бор объяснил природу узких резонансов, наблюдающихся в ядрах при высоких энергиях возбуждения, исходя из представления о существовании квази стационарных уровней ядер сложной (статистической) природы [1].

Если энергия падающей частицы такова, что полная энергия системы равна (или почти равна) энергии, соответствующей одному из уровней промежуточного ядра, то вероятность его образования значительно больше, чем в случае, когда энергия частицы соответствует промежутку между энергетич. уровнями. Поэтому возникают характерные максимумы выхода различных ядерных процессов в зависимости сечения σ от энергии падающих частиц. Если вероятность ядерного процесса определяется только резонансным рассеянием в единств. резонансе, то применима Брейта—Винера формула

$$\sigma = \pi \lambda^2 \frac{2J+1}{(2s+1)(2I+1)} \frac{\Gamma_p \Gamma_r}{(\epsilon - \epsilon_0)^2 + (\Gamma/2)^2} \quad (1)$$

Здесь J — спин промежуточного ядра (резонанса), s — спин частицы, I — спин ядра-мишени, λ — длина волны де Бройля, Γ_p , Γ_r — парциальные ширины резонанса, соответствующие входному и выходному каналам ядерной реакции, Γ — полная ширина резонанса, ϵ_0 — резонансная энергия частицы.

Полную амплитуду рассеяния f можно записать в виде

$$f = f_{nr} + f_p \quad (2)$$

где f_{nr} — амплитуда нерезонансного рассеяния, f_p — резонансного. Амплитуда f_p связана с сечением σ_p . Амплитуду f_{nr} обычно определяют с помощью оптической модели ядра, исследуя упругое резонансное рассеяние, для k -рого $f_p = \Gamma$.

Впервые резонансное рассеяние медленных нейтронов наблюдал Э. Ферми с сотрудниками в 1934 [2] (см. Нейтронная спектроскопия). Ими было обнаружено, что в некоторых случаях поперечные сечения захвата нейтронов значительно превосходят размеры ядер, что связано с квантовомеханич. природой рассеяния и большим значением λ . В дальнейшем благодаря возможности плавного изменения энергий бомбардирующих частиц (ускоренных с помощью электростатич. ускорителей) исследования резонансного рассеяния зарядж. частиц были осн. методом получения информации об уровнях ядер и их квантовых характеристиках

(спине, четности), о парциальных и полных ширинах состояний.

Если плотность состояний промежуточного ядра невелика и справедлива ф-ла (1), то в случае зарядж. частиц нерезонансная амплитуда f_{nr} определяется кулоновским рассеянием, а ширина Γ гл. обр. связана с каналом распада. При этом часто достаточно измерить зависимость сечения от энергии под некот. углом, чтобы судить об орбитальном моменте частицы, захваченной в

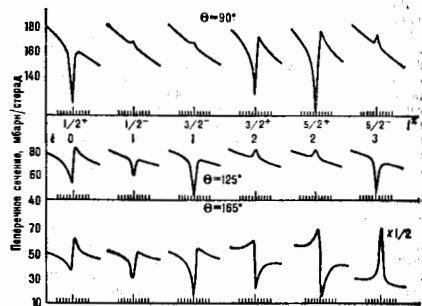


Рис. 1. Зависимость сечения резонансного рассеяния от орбитального момента l , падающих ядер при разных углах рассеяния.

резонансное состояние. Простота определения орбитального момента является следствием интерференции амплитуд кулоновского рассеяния и амплитуды, соответствующей брейт-винеровскому резонансу (рис. 1).

Открытие аналоговых резонансов (см. Аналоговые состояния) потребовало увеличения энергии ускорителей и улучшения их энергетич. разрешения, необходимого для измерения тонкой структуры изобар-аналоговых резонансов.

В ядерной физике низких и средних энергий Р. я. п. используются для исследования т. н. квазимолекуляр-

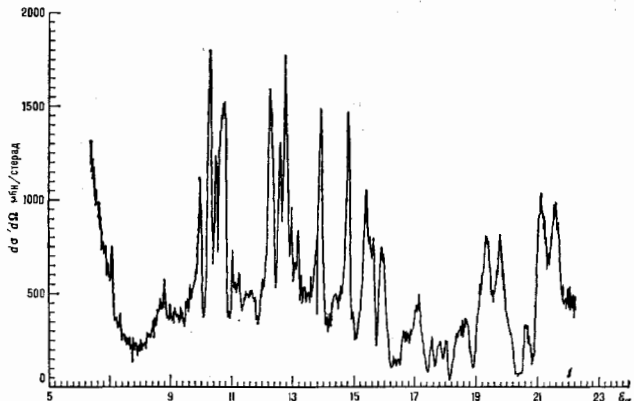


Рис. 2. Спектр α -частиц отдачи при торможении ионов ^{140}O в Ne.

ных ядерных систем типа α -частица — ядро, два ядра ${}^4\text{He}$, два ядра ${}^{24}\text{Mg}$ и т. д. (см. *Ядерные ассоциации мюнов* [3]). В этом случае выделение состояний в области высоких энергий возбуждения, когда открыто много каналов распада составной системы, объясняется своеобразной структурой уровней, приводящей к преобладающей вероятности распада по одному каналу. Примером такого выделения может служить спектр, полученный при торможении ускоренных ионов ${}^{16}\text{O}$ с энергией 90 МэВ в He (рис. 2). Наблюдаемые резонансы в спектре α -частиц отдачи связаны с тем, что при определ. энергии ионов ${}^{16}\text{O}$ и ядер He существуют уровни составной системы ${}^{20}\text{Ne}$ с характерной квази-молекулярной структурой уровней (${}^{16}\text{O} + \alpha \rightarrow {}^{20}\text{Ne}$).

Большие сечения, характерные для резонансных реакций при определ. энергиях, являются основой для элементного анализа материалов. При высоких энергиях ускоренных частиц резонансные ядерные реакции являются инструментом поиска новых частиц — резонансов.

Лит.: 1) В о h r N. K a l c a k a r P., On the transmutations of the atomic nuclei by impact of material particles, «Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Math.-Fys. Medd.», 1937, v. 14, № 10, p. 1; 2) F e r m i E. и др., Azione di sostanze idrogenate sulla radioattività provocata da neutroni, «Ric. Scienc.», 1934, v. 5, p. 1282; 3) Z u t m a H. S. W., Spine and spin alignment of heavy ion nucleus resonances, Proc. Fifth Int. Conf. Clustering Aspects in Nuc. and Subnuc. Systems, Kyoto, 1988, 1., «Phys. Soc. Jpn.», 1989, v. 58, Suppl., p. 37. В. З. Гольдберг.

РЕЗОНАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ — усилитель электрических колебаний, содержащий резонансный колебательный контур и имеющий вследствие этого большое усиление в сравнительно узкой полосе частот вблизи резонансной частоты (см. также *Резонанс*), что позволяет с помощью Р. у. не только усиливать, но и выделять колебания с требуемыми частотами. Р. у. широко используются в радиотехнике, гл. обр. в качестве малошумящих избират. усилителей на входе радиоприёмных устройств и мощных усилителей на выходе радиопередающих устройств. По принципу работы разделяются на Р. у., построенные на взаимных усилит. элементах без внеш. положит. обратной связи, и Р. у. регенеративные.

В Р. у. первого типа усиливаемые колебания подаются к управляющему электроду (транзистора, электронной лампы, ИС), резонансный контур включён в цепь выходного электрода и возбуждается его током. Используются преим. на умеренно высоких частотах, на к-рых значительно развязка между выходной и входной цепями управляющего электрода. В качестве резонансного контура применяют обычно простые одиночные контуры с сосредоточенными параметрами и малым собств. затуханием ($d \ll 1$). В режиме усиления малы колебаний макс. коэф. усиления напряжения при резонансе $K_{\text{макс}} = S R_0$, где S — крутизна усилит. элемента, R_0 — эквивалентное сопротивление резонансного контура на резонансной частоте f_0 . Амплитудно-частотная характеристика при малых расстройках Δf от частоты резонанса описывается выражением

$$\frac{K}{K_{\text{макс}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\Delta f / f_0 d)^2}}$$

где K — коэф. усиления при расстройке Δf ; полоса пропускания на уровне 3 дБ $\Pi = f_0 d_3$, где d_3 — результирующее затухание шунтированного др. цепями резонансного контура. Фазовая характеристика и переходные характеристики Р. у. также определяются гл. обр. соответствующими характеристиками резонансного контура. Для неискажённого усиления больших модулируемых колебаний стремится к линейзации динамик. колеб. характеристики Р. у. — зависимости первой гармоники выходного тока усилит. элемента от амплитуды напряжения на управляющем электроде.

В резонансный контур регенеративных Р. у., включённый в тракт усиливаемых колебаний на проход или на отражение, вносится отрицательное дифференциальное сопротивление, обусловленное введением по-

ложительной обратной связи (при неважных усилит. элементах), разл. физ. явлениями в полупроводниковых диодах (туннельных, лаанно-продольных, диодах Гавана и др.), изменением реактивного параметра резонансного контура под действием генератора *малячки* (параметрич. усилитель) и т. д. Р. у. находят применение гл. обр. в СВЧ-диапазоне, где обеспечение хорошей развязки между выходными и входными цепями трёхдиодных усилит. элементов затруднено. В качестве резонансного контура используются *объёмные резонаторы* и резонаторы из отрезков *линий передачи* разл. типов: полосковых, щелевых, компланарных, коаксильных, волноводных и др. Макс. коэф. усиления мощности при резонансе регенеративного Р. у. отражат. типа $K_{\text{Р. у.}} = 4R_0^2 / (R_0 + r_0)^2 (1 - \gamma)^2$, где R_0 — волновое сопротивление согласованного тракта усиливаемых колебаний, r_0 — сопротивление собств. потерь регенерирующего элемента, $\gamma = R_0 / (R_0 + r_0)$ — коэф. регенерации, R_0 — входное в резонатор отрезок, сопротивление; полоса пропускания при одноволновом резонансе $\Pi = f_0 d_3 (1 - \gamma)$. При $\gamma \rightarrow 1$ возрастает усиление, но сужается полоса пропускания, и на практике при $K_{\text{Р. у.}} > (10-20)$ дБ полоса сокращается до единичных процентов, а Р. у. переходит в режим генерации. В таких Р. у. для разделения входящей и усиленной отражённой волны используют взаимные элементы — ферритовые циркуляторы. Регенеративные Р. у. проходного типа ещё более уязвимы и имеют более высокий уровень собств. шумов, поэтому применяются реже отражательных, особенно в малошумящих радиоприёмных устройствах.

Лит.: Р и з и н А. А., Основы теории усилительных схем, 2 изд., М., 1954; Радиоприёмные устройства, под ред. А. П. Жуковского, М., 1989.

Н. Н. Фокин.

РЕЗОНАНСНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ — ускоритель элементарных частиц, в к-ром ускорение производится переменным высокочастотным электрич. полем. К Р. у. относятся *линейные ускорители* и все *циклические ускорители*, кроме *бетатронов*. В Р. у. частицы проходят ускорение промежутки лишь в те моменты времени, когда поле в них находится в *равновесной фазе* или вблизи неё. В линейных ускорителях частицы последовательно проходят ряд таких промежутков, в циклических — многократно возвращаются к одним и тем же промежуткам, постепенно увеличивая свою энергию.

Л. Л. Гольдберг.

РЕЗОНАНСЫ (резонансные частицы) — короткоживущие возбуждённые состояния ядернов. В отличие от др. нестабильных частиц, Р. распадаются в осн. за счёт сильного взаимодействия. Поэтому их времена жизни лежат в интервале $10^{-22}-10^{-24}$ с, что по порядку величины близко к характерному ядерному времени ($\sim 10^{-22}$ с).

В зависимости полных эфф. сечений рассеяния σ от энергии E (в системе центра инерции) Р. часто проявляются в виде колоколообразного (т. н. брейт-вингеровского) максимума:

$$\sigma(E) = \sigma_0 \frac{\Gamma^2/4}{(\sigma_0 - E)^2 + (\Gamma^2/4)} \quad (1)$$

Энергия E_0 , соответствующая максимуму сечения $\sigma = \sigma_0$, сопоставляется с массой Р., $M = E_0/c^2$. (Обычно в физике элементарных частиц используется система единиц, в к-рой $\hbar = c = 1$; тогда $M = E_0$.) Полная ширина Γ резонансовой кривой на половине её высоты определяет время жизни Р.: $\tau \approx \hbar/\Gamma$ (в соответствии с *неопределенности соотношением* между энергией и временем). Для определения сдвига Р., как и в явном, необходим более тщательный анализ угл. зависимости дифференц. сечения упругого рассеяния с целью нахождения той парциальной амплитуды, в к-рой проявляется этот максимум (см. *Рассеяние микрочастиц*, *Поляризационные эффекты* в рассеянии частиц).

Первый Р. открыт в нач. 1950-х гг. Э. Ферми (E. Fermi) с сотрудниками при изучении процесса взаимодействия π^- -мезонов с протонами на протонном

циклотрон в Чикаго (США). В совр. обозначениях это был P_{1, Δ_1}^+ или $\Delta_{2,3}$ (1232), где первая цифра индекса у символа P , означает удвоенный *изотопический спин* l частицы, вторая — её удвоенный *спин* J (в скобках указана масса P , в МэВ). Ширина этого P , $\Gamma = 116$ МэВ (т. е. время жизни $\tau = 5,7 \cdot 10^{-24}$ с). В дальнейшем этот P , был обнаружен и в системе (pp).

Осн. часть P , была открыта в 60-х гг. в экспериментах, выполненных на протонных ускорителях. P , делится на 2 группы: b и a и о н и е P , обладающие *барийным числом* ($B = 1$) и распадается на мезоны и один стабильный барий; m с а о н и е P , ($B = 0$), распадается на мезоны. P , с ненулевой *странностью*, нац. странами. К 1988 открыто более 300 P , к-рые группируются примерно в 40 барийных и 30 мезонных *изотопических мультиплетов*. Массы наблюдаемых барийных P , лежат в интервале от 1,2 до 4 ГэВ, мезонные — от 0,7 до 2 ГэВ. Исключение составляют новые мезонные P , массы к-рых достигают 9–10 ГэВ (см. *Ядерный, Очарованные частицы, Интеграл-частицы*). Ниж. границы массовых спектров P , определяются массами ядерно-стабильных (стабильных) относительно распадов за счёт сильного взаимодействия мезонов и бариев, а верхние — экстрем. возможностями их образования (ядерно-стабильные частицы условно относят к стабильным частицам).

Осн. методы обнаружения P , таковы.

а) Наблюдение максимума в полном аффективном сечении рассеяния. В полном сечении наблюдается колонолобобразный максимум $\sigma(\theta) \sim |\Gamma_{\text{вв}}(\theta)|^2$, положение и полная ширина к-рого равны соответственно M и Γ . Этот метод, однако, не позволял провести полного определения квантовых чисел P , в частности спина.

б) Проведение фазового анализа. Здесь исходными измеримыми величинами являются дифференц. сечения уругого рассеяния, т. е. сечения, измеренные как ф-ция угла рассеяния θ и полной энергии E . Квантовомеханич. амплитуда рассеяния $T(\theta, E)$ затем разлагается в ряд по *сферическим функциям*, а в простейшем бесспиновом случае — по полиномам Лежандра $P_l(\cos\theta)$:

$$T(\theta, E) = \sum (2l+1) P_l(\cos\theta) T_l(E). \quad (2)$$

Коэф. $T_l(E)$ этого разложения — *парциальные волны* рассеяния с орбитальным (угловым) моментом, равным целому положит. числу l , — определяются из эксперим. данных как комплексные ф-ции действ. переменного E . P , со спином $J = l$ проявляется в виде брейт-вингеровского вклада (1) в $T_l(E)$: $T_{\text{вв}}(E) = (\Gamma/2)/(M - E - i\Gamma/2)$. Этот метод позволяет определять все характеристики P , (массу, ширину, спин, *чистоту* и т. д.).

Методы а) и б) служат в осн. для обнаружения барийных P .

в) Поиск максимумов в массовых распределениях используется при обработке данных по неупругим реакциям вида $a + b \rightarrow c_1 + c_2 + \dots + c_n$, когда в результате соударения двух частиц a и b возникает n частиц ($n \geq 3$). Здесь строят распределение числа событий N (двумя (или несколькими) выделенными в конечном состоянии частицами, напр. c_1, c_2 , в зависимости от суммарной энергии этих частиц в их системе центра инерции; и этой системе суммарная энергия $E_{12} = E_1 + E_2$ определяет т. н. *эфф. массу* M_{12} пары частиц $c_1 + c_2$. Распределение по M_{12} наз. *массовым распределением*. Максимум в массовом распределении около ср. значения $M_{12} = M^*$ интерпретируется как P , с массой M^* , к-рый может распадаться на частицы c_1 и c_2 . Данный метод можно успешно применять и в тех случаях, когда P , распадается на сравнительно большое число частиц.

Вариантом этого метода может считаться метод «ведущей массы». Он используется в тех случаях, когда, напр., $n = 3$ и регистрировать частицу c_3 легче,

чем частицы c_1 и c_2 . Энергию пары частиц c_1, c_2 вычисляем по разности $E_{12} = E_{\text{аб}} - E_3$ (как «ведущую энергию»). P , проявляется как максимум в распределении по «ведущей» массе. Изучение массовых распределений — осн. способ обнаружения мезонных P .

P , лежащие в верх. части массового спектра, обладают большими спинами и большими ширинами. Наибольший надёжно установленный спин $J = 11/2$ [$P_{\Delta_{11}}$ (2420)]. Эти P , могут распадаться мн. способами.

Кол-во возможных каналов распада быстро увеличивается с ростом массы P . В области 1,5–2 ГэВ барийных P , напр., имеют ок. 5 разл. каналов распада. Важная особенность механизма многочастичных каналов распада тяжёлых P , — его каскадность (многоступенчатость). Напр., в распаде нестранного барийного $P_{\Delta_{3,7}}$ (1950) доминирует канал $\Delta_{3,7} \rightarrow l + N$, однако он идёт в 2 этапа: сначала $\Delta_{3,7}$ распадается на ливон и $\Delta_{3,3}$, а затем $\Delta_{3,3}$ — на l и N .

Несмотря на нек-рый рост полной ширины (т. е. полной вероятности распада), с возрастанием энергии вероятности распадов в каждый данный канал уменьшаются. Это затрудняет обнаружение и изучение свойств P , с массами $M > 2$ ГэВ.

P , с одинаковыми спинами и сумм. чётностью во мн. случаях удается объединить в семействах — т. н. *унитарные мультиплеты*, отражающие наличие приближённой симметрии сильного взаимодействия относительно преобразований из группы $SU(3)$.

Массовые спектры P , проявляют нек-рые специфич. закономерности. Так, зависимость спинов P , (мезонных и барийных) от квадратов их масс хорошо описывается линейными ф-циями (т. н. *траекториями Редже*) $J = a + bM^2$, где a — число, $b \approx 1$ ГэВ² — наклон этих траекторий (см. *Редже полюсов метод*). Линейность этих зависимостей и универсальность значений b для мезонных и барийных траекторий пока не получила удовлетворит. теоретич. объяснения.

При описании P , как с помощью траекторий Редже, так и с помощью унитарных мультиплетов на одну траекторию Редже или в один мультиплет могут входить как P , так и стабильные адроны. Это свидетельствует о близкой динамич. природе происхождения этих частиц. Т. о., деление адронов на стабильные частицы и P , по известной степени случайно и обусловлено соотношением между массами P , и массами возможных продуктов распада, подобно тому как нестабильность нейтрона относительно β -распада связана с тем, что $m_n > m_p + m_e + m_{\nu}$ (где m_n — массы соответствующих частиц).

Лит.: Хил Д. Р. Д. Резонансные частицы, в ян.: *Элементарные частицы*, пер. с англ., М., 1965; Мандельштам С., Растущие траектория Редже и динамика резонансов, пер. с англ., *УФН*, 1970, т. 101, в. 3, с. 423; Дубов в. о. в. М. С., Свия и о. в. Ю. В., Распад резонансных состояний и определение их квантовых чисел, там же, в. 4, с. 655; Ширков Д. В., Свойства траекторий полюсов Редже, там же, 1970, т. 102, в. 1, с. 87; Н. о. в. Ю. В., Введение в теорию элементарных частиц, М., 1972.

РЕЗОНАТОР (от лат. *resono* — звучу в ответ, откликаюсь) — устройство или природный объект, в к-ром происходит накопление энергии колебаний, поставленной извне. Как правило, P , относятся к линейным колебл. системам и характеризуются т. н. резонансными частотами. При приближении частоты внеш. воздействия к резонансной частоте в P , наблюдается достаточно резкое увеличение амплитуды вынужденных колебаний. Это — явление *резонанса*. После отключения внеш. источника колебания внутри P , какое-то время сохраняются. Они совершаются на частотах, близких к резонансным, и представляют собой свои собственные или свободные колебания P . Если пренебречь диссипацией (в т. ч. и потерями на налучение), то P , ведёт себя как идеальная консервативная колебл. система, обладающая дискретным спектром собств. колебаний. При наличии потерь чисто гармонич. собств. колебания невозможны, соответствующие им резонансные кривые P .

упряются. Это упрощено характеризуют добротностью $Q = \omega/\Delta\omega$ (ω — резонансная частота, $\Delta\omega$ — ширина резонансной кривой). Добротность определяет отношение запасённой в Р. колебат. энергии W к энергии потерь за один период колебаний, $Q = \omega W/P$ (P — мощность потерь); однако следует иметь в виду, что само понятие запасённой энергии в диссипативных системах является до век-рости степенно условным, зависящим от принятой модели (идеализации) Р.

Р. различаются прежде всего физ. характером происходящих в них процессов. Так, существуют механит., акустич., эл.-маг. и др. Напр., одномерный механит. Р. является струна с закреплёнными концами, двумерный — уругая мембрана. В случае акустич. колебаний роль Р. часто выполняют разл. трубы, колбы, сосуды, наполненные газом (воздухом) (см. Резонатор акустический). Акустическими Р. могут служить комнаты, залы или их отд. части, что приводит к эффекту реверберации (продолжительного эхового звучания на избранных частотах) и нарушает акустич. совершенство помещений. Уникален по своим свойствам (диапазонность, прерастраиваемость и т. п.) Р. голосового аппарата человека и животных.

Простейший Р. для эл.-магн. колебаний — колебательный контур, состоящий из индуктивности L , ёмкости C , сопротивлений R ; его собств. частота $\omega = (LC)^{-1/2}$, а добротность $Q = R^{-1}(L/C)^{1/2}$. Размеры колебат. контура l должны быть малы по сравнению с длиной волны $\lambda = 2\pi c/\omega$ ($l \ll \lambda$). Иначе существенны будут потери на излучение эл.-магн. волн, что ведёт к уменьшению Q . Для снижения таких потерь применяют экранирование Р. в виде замкнутых объёмов с хорошо проводящими стенками. Это — т. н. объёмные резонаторы, или андвибраторы (в отличие от экранированных, поля к-рых сосредоточены вне формирующих поверхностей). Объёмные Р.—колебат. системы с распределёнными параметрами. Их форма может быть произвольной, но для простой экраниров. полости (сферической, цилиндрической и т. п.) ниж. частота собств. колебаний (мод) всегда обратно пропорциональна времени пребывания эл.-магн. волн между стенками $\omega_{\text{ниж}} \sim c/l$. Объёмные Р. служат в технике СВЧ. В миллиметровом, субмиллиметровом и оптическом диапазонах чаще всего используют открытые резонаторы, размер к-рых $l \gg \lambda = 2\pi c/\omega$. Их резонансные моды формируются в результате многократного отражения квазиоптич. лучков эл.-магн. волн от двух или неск. зеркальных поверхностей (см. Оптический резонатор, Квантовая, Интерферометр Фабри — Перо). Спектр собств. колебаний открытых Р. значительно разрежен по сравнению со спектром полностью экраниров. систем, т. к. объединённые в лучки группы мод, попадающие мимо зеркал, высвечиваются и, следовательно, относятся к низкодобротным. Открытые Р. играют важную роль в работе лазеров и лазеров. В реалт. диапазоне обычные зеркала перестают быть хорошими отражателями, поэтому их заменяют периодич. многослойными структурами, обеспечивающими отражение вследствие брэгговского рассеяния (см. Брэгг — Вульфа условие).

Лит.: В а н и н с т е й н Д. А., Открытые резонаторы в открытых волноводах, М., 1966; И с а к о в и ч М. А., Общая акустика, М., 1973; Н и к о л с к и й В. В., Н и к о л с к и й З. И., Электродинамика и распространение волн, 3 изд., М., 1989; А ч а н к и в Ю. А., Оптические резонаторы и лазерные лучки, М., 1990. М. А. Миллер, А. И. Смирнов. РЕЗОНАТОР АКУСТИЧЕСКИЙ (резонатор Гельмгольца) — сосуд, сообщающийся с внеш. средой через вебольное отверстие или трубу (горло). Характерная особенность Р. а. в том, что длина волны его собств. НЧ-колебаний значительно больше размеров Р. а. Для Р. а. с горлом собств. частота $f_0 = (c/2l)\sqrt{S/V}$, где c — скорость звука в воздухе, S — площадь поперечного сечения, l — длина трубки, V — объём сосуда. Если Р. а. поместить в гармонич. звуковое поле с частотой f_0 , в нём возникают колебания с амплитудой, во мно-

го раз превышающей амплитуду поля (резонанс). В негармонич. звуковом поле Р. а. реагирует только на колебания с частотой f_0 . Поэтому набор Р. а. с разл. собств. частотами может применяться для анализа звука. При наличии трения в горле Р. а. в нём возникает сильное поглощение звука на частоте f_0 , что используется для создания т. п. резонансных звукопоглотителей в архитектурной акустике. Р. а., помещённые на стенках звукопроводов, служат как элементы резонансных отражателей для уменьшения передачи НЧ-шума по звукопроводам. Пузыри в жидкости и воздушной полости в вен-рых др. средах (напр., резине) также являются Р. а., поэтому наличие большого числа пузырей в воде вызывает сильное поглощение звука, что препятствует распространению звуковых волн.

Теория Р. а. разработана Г. Гельмгольцем (G. Helmholtz) (1860) и Дж. Рэлеем (J. Rayleigh) (1877—78). РЕЗОНАТОР АНИЗОТРОПНЫЙ — оптический резонатор, содержащий анизотропные оптич. элементы. Исследование поляризац. свойств Р. а. проводится обычно Джонса матричным методом. В соответствии с этим методом для нахождения вектора Джонса

$$E = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix},$$

характеризующего состояние поляризации моды резонатора в фиксированном поперечном сечении резонатора, необходимо найти матрицу Джонса M обхода резонатора с началом в данном сечении и потребовать, чтобы вектор Джонса после обхода резонатора $M \cdot E$ с точностью до постоянного множителя χ совпадал с исходным вектором:

$$M \cdot E = \chi E. \quad (1)$$

Если матрица Джонса, описывающая поляризац. свойства всей совокупности оптич. элементов, обраающих резонатор, имеет вид

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix},$$

то при

$$\chi = \chi_{1,2} = \frac{1}{2} [a_{11} + a_{22} \pm \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 - 4a_{12}a_{21}}] = \\ = a_{1,2} \exp i\varphi_{1,2}$$

(собств. значения матрицы M) у-рние (1) имеет нетривиальные решения $E_{1,2}$, описывающие состояния поляризации волны, не изменяющиеся при полном обходе резонатора. Модуль собств. значения $a_{1,2}$ определяет ослабление амплитуды волны с поляризацией $E_{1,2}$ при обходе резонатора. Если $|a_1| \neq |a_2|$, то моды резонатора с разным состоянием поляризации обладают разными потерями. Разность фаз $\varphi_1 - \varphi_2$ собств. значений определяет разность частот $\Delta\nu$ резонансных типов колебаний с собств. состояниями поляризации:

$$\Delta\nu = \frac{c}{2\pi L} (\varphi_1 - \varphi_2),$$

где L — длина оптич. пути.

Матрица Джонса обхода резонатора в противоположном направлении M' в общем случае отличается от M , и потому в одном и том же поперечном сечении резонатора поляризац. характеристики волн, распространяющихся в противоположных направлениях, а также их собств. частоты и потери неодинаковы. Этот эффект в кольцевых резонаторах, содержащих взаимные элементы оптические, напр. оптич. элементы на основе Фарадея эффекта, может приводить к подавлению одной из встречных волн.

Если линейный резонатор не содержит магнитооптич. анизотропных элементов, то $M' = M'$ (где индекс т означает операцию транспонирования). Тогда собств. значения матриц M' и M одинаковы, а собств.

состояния поляризации волн, распространяющихся в произвольных направлениях и соответствующие разл. соств. значениям, ортогональны:

$$E'_{1,2} \cdot E'_{2,1} = 0.$$

Если $M' = M$, то соств. типы полей линейного резонатора представляют собой эллиптически поляризованные стоячие волны.

Р. а. применяют: в лазерных гироскопах для подавления одной из встречных волн; для прецизионного измерения анизотропии оптич. элементов, для чего исследуемый элемент помещают в резонатор и по характеру соств. состояний поляризации резонатора судят об анизотропных свойствах элемента; для управления энергией, поляризац. и частотными параметрами выходного излучения. В частности, в Р. а. возможно осуществить селекцию продольных мод резонатора (см. *Селекция мод*). Для этого в линейный резонатор помещают поляризатор и двулучепреломляющую пластинку, гл. осн к-рой повернуты относительно осей поляризатора на угол φ . Модули соств. значений матрицы Джонса обхода такого резонатора равны

$$|a_{11}|^2 = 0 \quad \text{и} \quad |a_{21}|^2 = 1 - \sin^2 2\varphi \sin^2 2\varphi,$$

где $\varphi = \text{inv}(n_e = n_o)/c$ — разность набега фаз необъемного и обыкновенного лучей в двулучепреломляющей пластине, d — толщина пластины, n_o и n_e — показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн. Потери моды резонатора, соответствующей второму соств. значению, определяются выражением $\sin^2 2\varphi \sin^2 2\varphi$. Т. к. величина φ зависит от частоты ν , то потери периодически меняются с частотой. Расстояние по частоте между двумя минимумами потерь

$$\Delta\nu = c/2d |n_e - n_o|.$$

Благодаря такой дискриминации мод по потерям осуществляется селекция продольных мод в резонаторах подобного типа.

Лит.: Бывков В. П., Специальные оптические резонаторы, в кн.: Справочник по лазерам, пер. с англ., т. 2, М., 1978; Джерард А., Берч Дж. М., Введение в матричную оптику, пер. с англ., М., 1978; Водотович А. П., Магнитооптика газовых лазеров, Минск, 1984; Войтович А. П., Севериков В. Н., Лазеры с анизотропными резонаторами, Минск, 1988. О. О. Силчев.

РЕЗОНАТОР ДИСПЕРСИОННЫЙ — оптический резонатор, содержащий элементы с резкой (в масштабах контура усиления активной среды) зависимостью затухания мощности от длины волны излучения. Р. д. является неотъемлемой частью широкодиапазонных перестраиваемых лазеров с широкой полосой усиления активной среды. В лазерах, содержащих Р. д., спектр выходного излучения формируется вблизи минимума контура затухания, поэтому осн. характеристика Р. д. является эфф. полоса пропускания, определяемая кривизной минимума спектрального контура затухания:

$$\delta\lambda_p = \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \beta}{\partial \lambda^2} \right)_{\lambda_0}^{-1/2},$$

где β — декремент затухания мощности за обход резонатора; λ_0 — длина волны, соответствующая наим. затуханию.

В Р. д. используются элементы с угл. дисперсией (*дифракционные решетки, спектральные призмы*) или амплитудной селекцией спектра (*интерферометры Фабри — Перо, резонансные отражатели и др.*). В резонаторах, содержащих элементы с угл. дисперсией, эфф. полоса пропускания зависит от геометрии резонатора и расходимости генерируемого излучения и с хорошей точностью оценивается ф-лой

$$\delta\lambda_p \approx \Delta\theta (\partial\varphi/\partial\lambda)_{\lambda_0}^{-1},$$

где $\Delta\theta$ — расходимость излучения, $(\partial\varphi/\partial\lambda)_{\lambda_0}$ — угл. дисперсия в произвольном сечении резонатора. В так

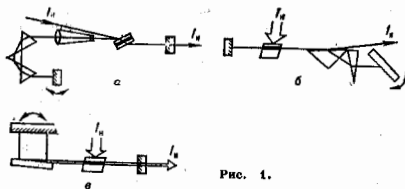


Рис. 1.

резонаторах широко используются телескопы, в т. ч. призмные, увеличивающие угл. дисперсию пропорц. кратности телескопа (рис. 1а — с, l_1, l_2 — соответственно интенсивности накачки и излучения).

Из элементов с амплитудной селекцией в Р. д. применяются интерферометры (эталоны) Фабри — Перо, эфф. полоса пропускания к-рых совпадает с шириной контура пропускания по уровню 0,5 (для идеального интерферометра). Используются также системы связанных резонаторов (см. *Селекция мод*), интерференционно-поляризац. фильтры (см. *Резонатор анизотропный*), акустооптич. фильтры и дефлекторы (см. *Акустооптика*) и др. элементы. Распространены резонаторы с многоступенчатой селекцией спектра (рис. 2),

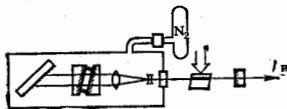


Рис. 2.

Ширина спектра излучения лазера с Р. д. зависит от режима работы лазера (импульсный или непрерывный), превышения над порогом генерации, конкуренции продольных мод и др. факторов. Так, в импульсном лазере с Р. д. ширина спектра генерации определяется эфф. полосой обр. и длительностью импульса генерации τ_n в соответствии с ф-лой

$$\delta\lambda_p = \delta\lambda_p (\tau_n / \tau_p)^{-1/2},$$

где τ_p — время обхода резонатора излучением.

Перестройка длины волны в лазерах с Р. д. осуществляется преим. поворотом дисперсионного элемента либо зеркала резонатора. Тонкая настройка длины волны в узком диапазоне достигается изменением давления газа внутри резонатора. Дисперсионные элементы вносят относительно большие потери на длине волны генерации (от неск. процентов до неск. десятков процентов), поэтому Р. д. применяются преим. в лазерах с большим коэф. усиления активной среды, напр. в лазерах на красителях и лазерах на центрах окраски.

Лит.: Анохов С. П., Марусий Т. Я., Соснов М. С., Перестраиваемые лазеры, М., 1982; Лысов В. Г., Сергеев С. Д., Чередицкий О. В., Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение, М., 1981. С. М. Нотьяло.

РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО [по имени англ. учёного О. Рейнольдса (O. Reynolds)] — один из *подобия критериев* для течений вязких жидкостей и газов, характеризующий соотношение между инерц. силами и силами вязкости: $Re = \rho v l / \mu$, где ρ — плотность, μ — коэф. динамич. вязкости жидкости или газа, v — характерная скорость потока, l — характерный линейный размер. Так, при течениях в длинных цилиндрич. трубах обычно $l = d$, где d — диаметр трубы, $v = v_{cp}$ — средняя по поперечному сечению скорость течения; при обтекании тел l — длина или поперечный размер тела, а $v = v_{\infty}$ — скорость невозмущённого потока, набегающего на тело. Р. ч. является также одной из

характеристик течения вязкой жидкости (газа). Для каждого вида течения существует такое критич. Р. ч. $Re_{кр}$, что при $Re < Re_{кр}$ возможно только ламинарное течение, а при $Re > Re_{кр}$ течение может стать турбулентным (см. Турбулентность). Напр., для течения вязкой несжимаемой жидкости в круглой цилиндрич. трубе $Re_{кр} = 2300$.

Лит. см. при ст. *Поведения теория*.
РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО акустическое — безразмерный параметр, использующийся в акустике для количественной характеристики соотношения нелинейных и диссипативных членов в ур-нии, описывающем распространение волны конечной амплитуды (см. *Нелинейная акустика*). В этом случае Р. ч.

$$Re_R = 2\pi\rho v/bk = (\epsilon/\pi)\rho v\lambda/b,$$

где v — амплитуда колеб. скорости частиц в волне, $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число, λ — длина волны, $b = (\epsilon/\eta) + \xi + \kappa(c_v^{-1} + c_p^{-1})$ — эфф. коэф. вязкости, представляющий собой сумму коэф. сдвигающего η и объёмной ξ вязкостей и члена $\kappa(c_v^{-1} + c_p^{-1})$, описывающего затухание звука вследствие влияния теплопроводности (здесь κ — коэф. теплопроводности, c_p и c_v — уд. теплоёмкости среды при пост. давления и объёме), ρ — плотность среды, $\epsilon = (\rho/2c_0^2) d^2\epsilon/d\rho + 1$ — нелинейный параметр, позволяющий учитывать влияние нелинейности ур-ния состояния среды, κ -края может оказаться доминирующей в сжимаемых средах (c — скорость звука, c_0 — её невозмущённое значение).

При малых значениях Re_R доминирует влияние вязкости и волна затухает раньше, чем нелинейные эффекты успевают развиться. При больших значениях Re_R осн. роль играет нелинейность, приводящая к искажению формы волны по мере её распространения и к образованию слабых ударных волн. Ширина δ фронта ударной волны также определяется акустик. Р. ч. согласно ф-ле $\delta/\lambda = 1/Re_R$. Коэф. поглощения α ϵ волны конечной амплитуды превышает маломолитудный коэф. поглощения α в Re_R раз. К. А. Наумович.

РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО магнитное, R_m — безразмерный параметр в магн. гидродинамике, характеризующий взаимодействие проводящих движущихся жидкостей и газов (плазмы) с магн. полем:

$$R_m = Lv^2\lambda\sigma/c^2.$$

(Здесь L — характерная длина, v — характерная скорость для рассматриваемого процесса; σ — электропроводность.) Магн. Р. ч. является критич. параметром, по его величине все процессы в магн. гидродинамике делятся на два класса: с $R_m \leq 1$, т. е. с малой проводимостью (напр., *низкотемпературная плазма*) и с $R_m \gg 1$, т. е. с большой проводимостью или большими размерами (астрофиз. объекты, высокотемпературная плазма). Подробнее см. в ст. *Магнитная гидродинамика*.

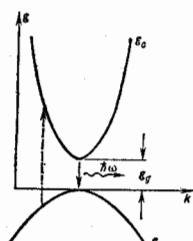
РЕКОМБИНАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (рекомбинационная люминесценция) — люминесценция полупроводника (и диэлектриков), обусловленная рекомбинацией неравновесных электронов и дырок. В отличие от др. видов люминесценции, под Р. и. понимается процесс, к-рому предшествует образование свободных носителей заряда. По способу такого возбуждения различают неск. видов Р. и.: катодoluminesценция (возбуждение электронных пучком), используемая в люминесцентных экранах и как метод хим. и структурного анализа, а также в *полупроводниковых лазерах*; электролюминесценция (инжекционная люминесценция; возбуждение происходит за счёт инжекции неосновных носителей через p — n -переход), применяемая в *светодиодах* и *инжекционных лазерах*; фотолюминесценция (возбуждение светом с энергией фотона λ_0 , превосходящей ширину

запрещённой зоны полупроводника ϵ_g). К. Р. и. относят также т. и. пробойное свечение, возникающее при ударной ионизации обратно-смещённого p — n -перехода [1].

Внутренним квантовым выходом Р. и. $\eta_{вк}$ наз. отношение числа квантов Р. и. к числу квантов возбуждающего света или к числу носителей, инжектируемых через p — n -переход. Наибольшим квантовым выходом обладают прямозонные полупроводники (рис. 1). Для идеального кристалла выполняется закон сохранения квазиимпульса, когда при поглощении или излучении фотона переход электрона из валентной зоны в зону проводимости (или наоборот) происходит «вертикально». Это означает, что квазиимпульсы электрона в зоне проводимости и в валентной зоне равны (импульс фотона пренебрежимо мал). Между возбуждением и Р. и. протекает т. н. процесс остывания горячего (возбуждённого) носителя. При низкой концентрации осн. носителей остывание происходит за счёт излучения фотонов, а при высокой — за счёт межэлектронных взаимодействий (см., напр., *Межэлектронное рассеяние*).

Рекомбинация, происходящая после остывания, сопровождается излучением фотонов с энергией, близкой к ширине запрещённой зоны ϵ_g (краевое излучение). Наб. квантовым выходом краевого Р. и. ($\eta \rightarrow 1$) обладают светодиоды на основе *гетероструктур* в системе Ga — Al — As [2]. В этом случае неосновной носитель, возникший в результате возбуждения, рекомбинирует не со своим партнёром по рождению, а с одним из множества осн. носителей легиров. полупроводника. Если электроны рекомбинируют, не успев остыть, то энергия фотонов $\lambda_0 > \epsilon_g$, однако квантовый выход горячей люминесценции на много порядков меньше, чем у краевой.

Рис. 1. Зонная диаграмма прямого полупроводника.

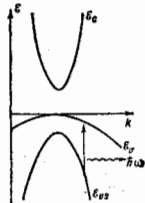


Пробойное свечение обычно представляет собой горячую люминесценцию дырок, возникающую при ударной ионизации. Дырки разгоняются электрич. полем по спиновоотщеплённой зоне v_2 и излучают свет, переходя

в валентную зону с тяжёлой эфф. массой m носителя (рис. 2). Спектр пробойного свечения широкий, а квантовый выход мал (порядка долей %).

Кроме межзонных переходов Р. и. может быть вызвано оптич. переходами типа примесный уровень — зона. Они существуют в случае непрямозонных полупроводников, когда переходы между экстремумами зоны проводимости и валентной зоны невозможны без участия фононов (рис. 3). С переходами примесь — зона связано, напр., свечение светодиодов на основе GaP. Спектральная полоса излучения типа примесь — зона, как и краевого, узкая ($\approx kT$). Краевое излучение при

Рис. 2. Зонная диаграмма прямого полупроводника с расщепленной валентной зоной.



в валентную зону с тяжёлой эфф. массой m носителя (рис. 2). Спектр пробойного свечения широкий, а квантовый выход мал (порядка долей %).

Кроме межзонных переходов Р. и. может быть вызвано оптич. переходами типа примесный уровень — зона. Они существуют в случае непрямозонных полупроводников, когда переходы между экстремумами зоны проводимости и валентной зоны невозможны без участия фононов (рис. 3). С переходами примесь — зона связано, напр., свечение светодиодов на основе GaP. Спектральная полоса излучения типа примесь — зона, как и краевого, узкая ($\approx kT$). Краевое излучение при

высоком уровне возбуждения испытывает сужение спектральной полосы. Этот уровень соответствует условию инверсии населённости квантовых состояний, к-рые участвуют в переходе. При этом краевое спонтанное излучение переходит в вынужденное (стимулированное [3]). Инверсия населённости в полупроводниках происходит, когда расстояние между квазиуровнями Ферми неравновесных электронов и дырок окажется больше Δg . Это же пороговое условие должно быть выполнено в активном слое полупроводникового лазера, когда в нём возникает генерация. Инжекционный лазер (на $p-n$ -переходе) отличается от светодиода тем, что грани кристалла образуют резонатор Фабри — Перо (см. *Оптический резонатор*). Когда порог генерации лазера превышен, то спектральная полоса Р. и. подвергается сужению.

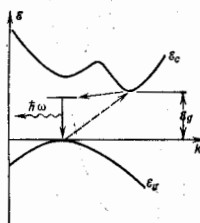


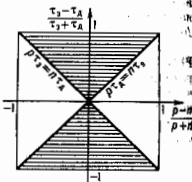
Рис. 3. Зональная диаграмма непрямого полупроводника.

Краевое спонтанное Р. и. GaAs и др. прямозонных полупроводников может обладать поляризацией. Причина поляризации — спин-орбитальное расщепление валентной зоны. В единичном акте рекомбинации электрона с лёгкой дыркой электрич. вектор излучения E колеблется преим. вдоль направления квазиимпульса k рекомбинирующих частиц. Степень поляризации такого излучения (согласно теории) $\sim 60\%$ [3]. В акте рекомбинации электрона с тяжёлой дыркой E колеблется в плоскости, перпендикулярной k ; степень поляризации при этом $\sim 100\%$. Когда квазиимпульсы носителей распределены изотропно, то поляризация излучения исчезает. Т. к. неравновесные носители, возникающие при пробеге $p-n$ -перехода, распределены по импульсам анизотропно, то Р. и. оказывается поляризованным [4, 5]. Анизотропия импульсного распределения рекомбинирующих носителей возникает и при туннельном просачивании через прямо смещённый $p-n$ -переход. В этих условиях также наблюдается поляризация Р. и. [6].

Лит.: 1) З. и С. Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., т. 2, М., 1984; 2) Алферов Ж. И. и др., 100% внутренний квантовый выход излучательной рекомбинации в трехслойных гетероструктурах на основе системы AlAs — GaAs, «ФТП», 1975, т. 9, с. 462; 3) Келдыш Л. В., Константинцов О. В., Перель В. И., Эффект поляризации при межзонном поглощении света в полупроводниках в сильном электрическом поле, «ФТП», 1969, т. 3, с. 1042; 4) Царенков В. В., Гладкий В. И., Эффект поляризации спонтанного рекомбинационного излучения полупроводника в электрическом поле, «ФТП», 1969, т. 3, с. 1038; 5) Константинцов О. В., Перель В. И., Царенков В. В., О поляризации спонтанного рекомбинационного излучения полупроводников типа арсенида галлия в электрическом поле, «ФТП», 1969, т. 3, с. 1038; 6) Алферов Ж. И. и др., Двухзонное туннелирование и поляризация излучения в гетероструктурах AlGaAs — GaAs — GaAs и $p-n$ -переходах в GaAs, «ФТП», 1969, т. 3, с. 1054. О. В. Константинцов.

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ — волны концентрации носителей заряда в холодной биполярной плазме полупроводников во внеш. электрич. поле (см. *Плазма твёрдых тел*). Возникают спонтанно, когда электрич. поле превосходит некоторое пороговое значение. Р. в. проявляются как колебания тока в образце, к-рому приложено пост. напряжение. Условие существования Р. в. в полупроводнике является наличие как электронов, так и дырок, концентрации к-рых не должны сильно отличаться. Др. условие состоит в том, чтобы времена жизни τ носителей были различными. Оба условия выполняются только при наличии глубоких примесных центров рекомбинации, уровни энергии к-рых располагают в ср. части запрещённой зоны полупроводника. Эти условия иллюстрируются диаграммой

Р. в. проявляются в потере устойчивости протекания электрич. тока. Его течение устойчиво лишь в слабых полях. Критич. значение напряжённости поля определяется условием, чтобы дрейфовая длина неравновес-



Области существования рекомбинационных волн для катионов: p ; n — равновесные концентрации дырок и электронов; τ_1 , τ_2 — их времена жизни.

ных носителей заряда превосходила их диффузную длину. С этим и связан механизм самовозбуждения Р. в., заключающийся в том, что избыточные носимые носители, возникшие благодаря случайной генерации с примесных центров захвата, не рекомбинируют там, где они родились, а уносятся полем вместе с частично нейтрализующими их осн. носителями. Р. в. распространяются в сторону дрейфа более долгоживущих носителей заряда.

Р. в. наблюдались в кристаллах Ge n -типа с примесью Mn и Sb и в кристаллах Si n -типа с примесью Zn и P при темп-рах $T \sim 300$ К в электрич. поле порядка десятков В/см. Период колебаний тока от долей секунд до неск. мкс. Частота и амплитуда Р. в. чувствительны к изменению внеш. условий (темп-ры, магн. поля, освещения, к облучению потоком частиц). Это обуславливает возможности практич. использования Р. в. Созданы прецизионные датчики темп-ры, напряжённости магн. поля, механич. деформаций, мощности эл. магн. и корпускулярного излучений, а также микватюрные полупроводниковые генераторы и преобразователи.

Лит.: Константинцов О. В., Перель В. И., Царенков В. В., Условия существования медленных и быстрых рекомбинационных волн в полупроводниках, «ФТП», 1967, т. 9, с. 176; Карпова И. В. и др., Рекомбинационные волны в компенсированном германии, в кн.: Труды IX международной конференции по физике полупроводников, Москва, 23—29 июля 1968 г., т. 2, Л., 1969; Карпова И. В., Перель В. И., Дрейф импульса неравновесных носителей в биполярной плазме полупроводника с ловушками в условиях возбуждения неустойчивости типа рекомбинационных волн, «ФТП», 1976, т. 10, с. 428. О. В. Константинцов, Г. В. Царенков.

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ РАДИОЛИНИИ — спектральные линии радиодиапазона, образующиеся при радиц. переходах между высоковозбуждёнными состояниями (рибберовскими состояниями) атомов и ионов. Р. р. формируются в разреженной (концентрация электронов $\sim 10^{18}$ см $^{-3}$) низкотемпературной (электронная темп-ра ≤ 1 эВ) плазме туманной и межзвёздной среды. В указанных физ. условиях наиб. эфф. механизм заселения высоковозбуждённых атомных уровней — рекомбинация (отсюда назв.). Р. р. регистрируются методами радиоастрономии.

Для обозначения Р. р. указываются символ хим. элемента, главное квантовое число ниж. состояния l и греч. буква (α, β, γ и т. д.), соответствующая разности главных квантовых чисел верх. и ниж. состояний ($\Delta l = 1, 2, 3$ и т. д.). Так, напр., C747 β — линия, образованная при переходе с $n = 747$ на $n = 749$ в атоме углерода.

Возможность наблюдения Р. р. в спектрах диффузных туманностей (зона III) предсказал Н. С. Кардашев (1959). Р. р. открыты в 1964 в спектре туманности Омега (линия H90 α , $\lambda = 3,4$ см и H104 α , $\lambda = 5,2$ см) независимо двумя группами сов. радиоастрономов. До 1980 Р. р. наблюдались только в излучении (эмиссионные линии), а с 1980 — и в поглощении в направлении радиостанции Кассиопея А. Линия поглощения

образуются в холодных ($T = 20-100$ К) областях СП с концентрацией электронов $0,1-1$ см⁻³. Ширина Р. р. с $n > 100$ оказалась в резком противоречии с теорией штатовского упрощения спектральных линий в плазме, что дало толчок к пересмотру теории. Лишь в результате почти 20-летних усилий по улучшению теории и совершенствованию методов наблюдения удалось достичь согласия между теоретич. и наблюдаемыми ширинами Р. р. высших порядков.

Условия, при к-рых могут наблюдаться Р. р., довольно жесткие: с одной стороны, концентрация частиц в среде должна быть достаточно малой, иначе эффекты упрощения спектральных линий давлением размоют линии и сделают их ненаблюдаемыми, с др. стороны — число высоковозбужденных атомов на лучевые времена должно быть достаточно велико. Такие условия выполняются только в очень протяженных и разреженных космич. объектах (туманностях и межзвездной среде). Зарегистрированы Р. р. Н, He, C, Si, Fe, Al, Fe, Zn др. элементов в диапазоне длин волн от неск. миллиметров до 20 м с главными квантовыми числами от 30 до 747. Соответствующие им атомы достигают макроскопич. размеров (до 0,1 мм). Структура высоковозбужденных состояний атомов водородоподобна. Частоты Р. р. вычисляются по ф-ле Ридберга. Вследствие изотопического сдвига Р. р. H и He наблюдаются раздельно. Линии обильного и межзвездной среде углерода и более тяжелых элементов сливаются в одну бленду (полосу). С ростом n и Δn интенсивность Р. р. резко падает. Наблюдались Р. р. вплоть до $\Delta n = 6$.

В разреж. плазме туманностей и межзвездной среде населенности атомных уровней отклоняются от термодинамически равновесной. В радиодиапазоне $h\nu < kT$, поэтому даже слабое отклонение населенностей уровней от термодинамически равновесной может приводить к заметному мацерному эффекту в Р. р.

Р. р. — важный диагностич. инструмент совр. астрофизики. Радиолучение не поглощается пылевым компонентом межзвездной среды, поэтому в радиодиапазоне Галактика в осн. прозрачна. Это позволяет наблюдать в Р. р. очень удаленные объекты, к-рые из-за межзвездной поглощения не наблюдаются в оптич. диапазоне. Р. р. позволяют также исследовать динамику ионизов. водорода в Галактике, темп-ру, содержание гелия и др. характеристики зон III. Р. р. также обнаружены в спектрах др. галактик.

Лит.: Капдан С. А., Пикельер С. Б., Физика межзвездной среды, М., 1979; Radio recombination lines, ed. by P. A. Shaver, Dordrecht, 1980; см. также лит. при ст. Ридберговские состояния. С. А. Глазев.

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ — дефекты или примесные атомы (ионы) в кристаллич. решетке, на к-рых происходит рекомбинация электронно-дырочной пары (см. Рекомбинация носителей заряда). Процесс осуществляется путем последоват. захвата электрона и дырки центром. Энергетич. уровни Р. ц. лежат в запрещенной зоне, и центр обменивается носителями заряда с зоной проводимости (с) и валентной дырочной зоной (v) посредством процессов термич. испускания электронов из заполненного Р. ц. в зону с (с вероятностью в единицу времени g_0) и дырки из пустого Р. ц. в зону v (с вероятностью g_D), а также обратных процессов захвата свободного электрона па пустой Р. ц. (вероятность K_0) и свободной дырки на заполненный Р. ц. (K_D). Величины g_0, g_D, K_0, K_D определяются сечениями захвата электрона и дырки σ_e, σ_D , их тепловыми скоростями v_{th}, v_{thD} , энергетич. расстройством ϵ уровня Р. ц. и краев зон (ϵ_c, ϵ_v), кратностью вырождения уровня Р. ц. γ , статистич. факторами с- и v-зон (N_c, N_v). Они являются ф-циями темп-ры T и концентрации свободных электронов n и дырок p (при отсутствии вырождения):

$$K_0 = \sigma_e v_{th} n; K_D = \sigma_D v_{thD} p;$$

$$g_0 = \sigma_e v_{th} N_c \exp(-(\epsilon_c - \epsilon)/kT);$$

$$g_D = \sigma_D v_{thD} N_v \exp(-(\epsilon_v - \epsilon_D)/kT).$$

Для Р. ц. справедливы соотношения

$$K_D \gg g_0, K_0 \gg g_D,$$

т. е. заполненный электроном Р. ц. со значительно большей вероятностью захватывает дырку, чем испускает электрон в зону с, тогда как пустой — с большей вероятностью захватывает электрон, чем испускает дырку в зону v.

При др. соотношениях между величинами K_D, K_0 и g_0, g_D дефекты и примесные атомы будут играть роль центров притяжения и (ловушек) электронов ($g_0 \gg K_D, K_0 \gg g_D$), центров прилипания дырок ($g_D \gg K_0, K_D \gg g_0$) или центров генерации и носителей (если $g_0 \gg K_D, g_D \gg K_0$). Если захват хотя бы одного из носителей заряда центром происходит излучением фотона, уносящего осн. часть выделяющейся энергии, то он наз. центром излучат. и в случае с-и v-рекомбинации (ЦИР) или центром свечения (люминесценции). Др. часть энергии может выделяться в виде фононов. В разных ЦИР излучат. процесс реализуется разл. путями: а) при захвате свободного носителя на с- или v-ионы непосредственно в осн. состоянии центра; соответствующие сечения излучат. захвата $\sigma_{\text{изл}}^{s, v}$, $\sigma_{\text{изл}}^{D, v}$ лежат обычно в пределах $10^{-18}-10^{-20}$ см²; б) при переходе носителя, захваченного на мелкий возбужденный уровень ЦИР, в осн. состояние; в) при т. н. в-у-р-е центровом переходе захваченного носителя между находящимися в запрещенной зоне уровнями внутр. электронной оболочки глубокого Р. ц. (напр., 3d-оболочки атома переходного металла или 4f-оболочки редкоземельного атома); г) при т. н. туннельном межцентровом переходе носителей между уровнями близко расположенных донора и акцептора, составляющих единый Р. ц.

Захват каждого из носителей центром безызлучательной рекомбинации (ЦБР) происходит с передачей всей выделяющейся энергии решетке либо непосредственно в виде фононов (многофононный безызлучат. рекомбинация), либо сначала другому свободному или связанному носителю, к-рый затем отдает эту энергию решетке (оже-рекомбинация). Связанный носитель может находиться либо на том же (многозарядном) центре, либо на соседнем. Так, излучат. захват свободного электрона глубоким акцептором А может быть подвал безызлучат. захватом, если в решетке nearby А (на расстоянии, достигающем десятков А) находится заполненный (глубокий) донор Д. Выделяющаяся энергия уносится электроном донора, эмитируемым в с-зону. Такая донорно-акцепторная пара может рассматриваться как оже-центр безызлучат. рекомбинации.

Уровни центров многофононной безызлучат. рекомбинации обычно расположены nearby середины запрещенной зоны, их положение зависит от зарядного состояния центра, причём электрон-фононное взаимодействие в центре сильное. Такими центрами могут быть как точечные, так и протяженные дефекты, напр. крупные кластеры, включения др. фазы, дислокации.

При наличии у Р. ц. неск. метастабильных «конфигураций» (ориентаций, расстояний между компонентами центра и т. д.), соответствующих разл. минимума полной энергии, рекомбинация носителя может сопровождаться ва Р. ц. его переходом между метастабильными состояниями.

Лит.: Смит Р., Полупроводники, пер. с англ., 2 изд., М., 1982; Коварский В. А., Квантовая безызлучательная рекомбинация, М., 1988; Landsberg P. T., Adams M. J., Radiative and Auger processes in semiconductor, ed. of Luminescence, 1973, т. 1, р. 3; Бойч В-Вручич В. В., Квантовые переходы в Р. ц. Физика полупроводников, М., 1971; Милослав А., Примеси с глубокими уровнями в полупроводни-

На этом этапе Р. м. устанавливается внутр. квазиравновесие в системе магновов, однако M и M_2 сохраняют нач. значения. Характерное время этого этапа Р. м. имеет порядок $(kT_C/A)(T/T_C)^2$, где T_C — темп-ра Кюри (*Кюри точка*). Дальнейшая релаксация обусловлена слиянием и расщеплением магновов за счёт дипольного взаимодействия, а также их взаимодействием с фононами. При этом сначала устанавливается равновесное значение M , а затем происходит поворот намагниченности к направлению $H_{\text{эф}}$. Последний этап описывается ур-нием (2); типичные значения λ имеют порядок 10^6 с⁻¹.

На практике значит. вклад в диссипацию магн. колебаний вносит неоднородности кристалла: нарушение порядка в расположении магн. ионов в узлах решётки, рандомизация осей лёгкого намагничивания, поры, трещины, шероховатость поверхности и т. д. Неоднородности приводят к дополнит. рассеянию магновов — вклад этого механизма может на неск. порядков превосходить собственную спин-спиновую релаксацию. Значит, влияние на Р. м. оказывают также электроны проводимости в ферромагн. металлах, а также некоторые магн. ионы с сильной спин-орбитальной связью (напр., трёхвалентные лантаниды), выступающие посредниками между СС и решёткой. В малых магн. полях в Р. м. вносят вклад процессы вязкого движения доменных стенок (см. *Доменной стенки динамика*).

Р. м. в ферримагнетиках и антиферромагнетиках обусловлена в общем теми же механизмами, что и в ферромагнетиках, однако её проявления осложнены наличием неск. магн. подрешёток. Особый случай представляют *спиновые стекла*, характеризующиеся широким спектром времён Р. м. и длительной релаксацией метастабильных магн. состояний.

Динамика. Для них Р. м. обычно не выделяется в самостоят. объект исследования, поскольку подчиняется обычным законам взаимодействия электронов (связанных или свободных) с магн. полем. Ширина линии *циклотронного резонанса* в металлах и полупроводниках определяется длиной свободного пробега носителя заряда. Исключение составляют аномально сильные динамикетики — сверхпроводники, где процессы Р. м. наиб. существенны в смешанном состоянии *сверхпроводника второго рода*.

Методы исследования магнитной релаксации. Наиб. широко используются резонансные методы: *электронный парамагнитный резонанс*, *ядерный магнитный резонанс*, ферро-, ферри-, антиферромагнитный резонансы. Поперечная релаксация обычно проявляется в возрастании ширины ΔH резонансных линий до величины порядка $1/\tau_{\text{р}}$, а также в затухании сигналов синовой прецессии и синовой оси. Спин-решётчная релаксация определяет величину стационарного поглощения энергии резонансного ВЧ-поля; кроме того, время τ_1 измеряется по восстановлению равновесной намагниченности после возбуждения мощным радиопульсом. Р. м. проявляется также в частотной зависимости динамик. магнитной восприимчивости — в частности, в релаксат. поглощении энергии на частотах порядка $1/\tau_{\text{р}}$ и $1/\tau_1$. Применяются сочетания резонансных и нерезонансных методов, двойные резонансы, магнитоинт. эффекты и пр. Обширную информацию о Р. м. в магнитоупорядоченных веществах даёт набор, возбуждение *спиновой волн* с помощью ВЧ-накачки, изучение спиновых нестабильностей, параметрических ВЧ-эффектов и пр.

Изучение Р. м. предоставляет ценную информацию о природе магнетизма в разл. веществах, позволяет исследовать спин-спиновые, спин-фононные и электронно-ядерные взаимодействия, атомно-молекулярную подвижность в конденсиров. средах. Р. м. играет существенную роль в работе устройств магн. памяти и магн. записи (см. *Памяти устройства*), во мн. случаях определяет их быстроту и частотный диапазон; в методах получения сверхнизких темп-р с помощью адiabатич. размагничивания (см. *Магнитное охлаждение*); в квантовых парамагн. усилителях (мазерсах); в эффектах

динамик. поляризации ядер (см. *Ориентированные ядра*, *Оверхаузера эффект*) и т. д.

Лит.: Абрагам А., Ядерный магнетизм, пер. с англ., М., 1963; Альтшулер С. А., Козырев В. М., Электронный парамагнитный резонанс соединений лантаноидов промежуточных групп, 2 изд., М., 1972; Сикстер Ч., Основы теории магнитного резонанса, пер. с англ., 2 изд., М., 1981; Ахмедер А. И., Вэрвяхтар В. Г., Пелетинский С. В., Спиновые волны, М., 1967; Гуревич А. Т., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, М., 1973; Александров И. В., Теория магнитной релаксации. Релаксация в жидкостях и твёрдых немагнитных парамагнетиках, М., 1975; Абрагам А., Гольдман И. М., Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок, пер. с англ., т. 1—2, М., 1984.

В. А. Ашуркин

РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — заполняющее Вселенную практически изотропное ол.-магн. излучение с чернотельным спектром и темп-рой ок. 2,7 К (*фононое космическое излучение*), интерпретируемое как реликт нач. стадий её эволюции. Подробнее см. *Микроваповое фононое излучение*.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ (лоренц-инвариантность) — независимое физ. законов и явлений от скорости движения наблюдателя (или, точнее, от выбора *инерциальной системы отсчёта*). Р. и законов фундам. физ. взаимодействий означает невозможность ввести выделенную систему отсчёта и измерить абс. скорость тел. Принцип Р. и возник в нач. 20 в. в результате обобщения разл. опытных данных, начиная с отрицат. результата эксперимента Майкельсона — Морли (1881—87) (см. *Майкельсона опыт*). Ныне наилучшие и наиб. многочисл. подтверждения Р. и фундам. физ. взаимодействий дают опыты с элементарными частицами высоких энергий. Из принципа Р. и вытекает существование нек-рой универсальной макс. скорости распространения всех физ. взаимодействий; эта скорость совпадает со скоростью света в вакууме. Математически Р. и выражается в том, что ур-ния релятивистской механики Эйнштейна — Лоренца — Пуанкаре и электродинамики Максвелла (совокупность этих ур-ний образует спец. теорию относительности), а также теории сильного и слабого взаимодействий не изменяют своего вида, если входящие в них пространственно-временные координаты и физ. поля подвергнутся *Лоренца преобразованиям*. Для построения релятивистски инвариантной теории гравитат. взаимодействий понятие Р. и должно быть обобщено (см. ниже).

Фундам. свойством Р. и является то, что она имеет место для пространства и времени вместе (а не по отдельности), т. е. преобразования Лоренца перемешивают пространственную и временную координаты. Это привело к введению понятия пространства-времени — четырёхмерного псевдоевклидова многообразия, точками к-рого являются разл. события [А. Пуанкаре (H. Poincaré), Г. Минковский (G. Minkowski)]. Преобразование Лоренца можно интерпретировать как четырёхмерный гиперболич. поворот в этом многообразии.

В предельном случае относит. скоростей v , много меньших скорости света (когда пренебрегают всеми эффектами порядка v^2/c^2 и выше), Р. и переходит в галилееву (нерелятивистскую) инвариантность — инвариантность относительно преобразования Галилея (см. *Галилеев принцип относительности*).

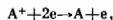
Р. и специальной (частной) теории относительности, к-рая является г. о. б. а. л. и о. й (в том смысле, что относит. скорости двух систем отсчёта и коэффициенты преобразований Лоренца постоянны во всём пространстве-времени), была обобщена в *общей теории относительности* Эйнштейна, где имеет место только л. о. к. а. л. и а. Р. и. — преобразования Лоренца относятся к дифференциалам координат, а их параметры зависят от точки. Появление Р. и было также обобщено (с сохранением осн. свойств) на многомерные теории физ. взаимодействий, в т. ч. гравитат. взаимодействия (см. *Кауличи — Кельна теория*, *Суперструны*).

А. А. Смирновский

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА — раздел теоретич. физики, в к-ром рассматриваются ре-

возбуждённом состоянии, а затем переходит в невозбуждённое, спонтанно излучая. Это излучение служит источником информации о механизме диссоциативной Р, а также о состоянии молекулярных ионов в плазме. Процесс диссоциативной Р. играет заметную роль в атмосфере Земли, в газоразрядной плазме и в активных средах газовых лазеров.

Тройная электрон-ионная рекомбинация происходит по схеме



состояние к-рой избыточная энергия уносится электроном плазмы. Именно таким процессом объясняется нейтрализация заряж. частиц в плазме атомарного газа с электронной темп-рой, много меньшей потенциала ионизации атомов, с достаточно высокой плотностью электронов ($\approx 10^{18} - 10^{14} \text{ см}^{-3}$), при преобладании атомарных ионов (давление газа $\lesssim 10$ тор). В этих условиях электрон-ионное соударение к-рое иона приводит к захвату одного из электронов в высоковозбуждённое состояние атома с энергией ионизации порядка kT_e . В результате последующих столкновений возбуждённого атома с электронами плазмы, а также процессов спонтанного излучения слабосвязанный электрон переходит в основное состояние атома. Поскольку в процессе тройной Р. слабосвязанный электрон большую часть времени проводит в высоковозбуждённых состояниях (см. *Ридберговские состояния*), структура к-рых мало зависит от сорта атома, коэф. тройной Р. при условиях, когда роль спонтанного излучения невелика, описывается выражением:

$$\alpha = \frac{C_{\text{ат}}}{m^{1/2} T_e^{1/2}} N_e \approx \frac{10^{-20} N_e}{T_e^{1/2}} \text{ [см}^3/\text{с]}.$$

Зависимость α от конкретного сорта атома заключена в слабо изменяющемся безразмерном множителе $C_{\text{ат}} \approx 3 \div 6$. В последней части этого выражения N_e измеряется в единицах см^{-3} , T_e — в эВ. Тройная электрон-ионная Р. играет существен. роль в плазме *дугового разряда*, в пучковой плазме высокого давления и *фоторезонансной плазме*.

Лит.: Смирнов В. М., Ионы и возбужденные атомы в плазме, М., 1974; Биберман Л. М., Воробьев В. С., Якубов П. Т., Кинетика неравновесной низкотемпературной плазмы, М., 1982; Еленин Я. В., Смирнов В. М., Элементарные процессы в плазме, в кн.: Основы физики плазмы, под ред. А. А. Галеера, Р. Судана, т. 1, М., 1983; Физика ионных и электрон-ионных столкновений, под ред. Ф. Бруйера, Дж. Мак-Гоуона, пер. с англ., М., 1986, гл. 1, 3, 6.

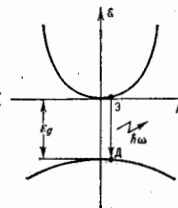
РЕКОМБИНАЦИЯ носителей заряда в полупроводниках — исчезновение пары свободных противоположно заряженных носителей в результате перехода электрона из энергетич. состояния в зоне проводимости в невалентное энергетич. состояние в валентной зоне (см. *Полупроводники*). При Р. выделяется избыточная энергия порядка ширины запрещённой зоны \mathcal{E}_g . Реализуют излучательную и безызлучательную Р. Первая сопровождается излучением светового кванта с энергией $h\nu \approx \mathcal{E}_g$ (см. *Рекомбинационное излучение*). При безызлучательной Р. избыточная энергия может непосредственно передаваться решётке путём возбуждения её колебаний (фононая безызлучательная Р.) или рекомбинирующий электрон посредством кулоновского взаимодействия может передать энергию др. электрону зоны, переводя его в высокоэнергетич. состояние (о ж е - р е к о м б и н а ц и я).

При безызлучательной фононой Р. электрону для выделения энергии $\sim \mathcal{E}_g$ требуется возбудить в одном акте неск. десятков фононов, т. к. обычно в полупроводниках $\mathcal{E}_g \sim 1 - 2$ эВ, а макс. энергия фонона составляет сотые эВ. Такие многофононные процессы в полупроводниках имеют ничтожно малую вероятность. Любая возможность передать избыточную энергию решётке не в одном акте, а в неск. последовательных актах на много порядков увеличивает вероятность Р. Эта возможность

реализуется на примесных центрах или дефектах кристаллич. структуры, к-рые образуют уровни в запрещённой энергетич. зоне (см. *Рекомбинационные центры*).

Излучательная и оже-Р. также могут протекать с участием примесных центров. Однако обычно эти процессы осуществляются непосредственно как прямые переходы зона проводимости — валентная зона. При излучательной Р. зона — зона законы сохранения энергии и импульса приводит к тому, что энергия светового кванта $h\nu \approx \mathcal{E}_g$, т. к. кинетич. энергии электронов и дырок много меньше \mathcal{E}_g . В то же время импульс кванта очень мал, так что электрон и дырка аннигилируют с противоположными импульсами $\pm k$ (рис. 1).

Рис. 1. Излучательная рекомбинация зона — зона в примозонном полупроводнике.



Вследствие этого в непрямозонных полупроводниках (Ge, Si) в обычных условиях излучательная Р. идёт только с участием примесей или колебаний решётки и имеет меньшую, чем в примозонных полупроводниках (GaAs, InSb), вероятность.

Число актов излучательной Р. в 1 с в единице объёма равно

$$r = \alpha n p, \quad (1)$$

где n , p — концентрации электронов и дырок, α наз. коэф. излучательной Р. Сечение излучательной Р. σ связано с α соотношением $\sigma = \alpha \langle v \rangle$, где $\langle v \rangle$ — ср. тепловая скорость электрона. В примозонных полупроводниках при $T = 300 \text{ К}$ $\sigma \approx 10^{-16} \div 10^{-18} \text{ см}^2$, в непрямозонных — $10^{-21} \div 10^{-22} \text{ см}^2$.

При оже-Р. взаимодействуют 3 частицы, энергия рекомбинирующей пары передается либо электрону, либо дырке. Число актов Р. в 1 с в этих случаях равно

$$r_0 = \alpha_0 n^2 p; \quad r_d = \alpha_d n p^2, \quad (2)$$

где α_0 , α_d — коэф. электронной и дырочной оже-Р. «Уходящий» носитель уносит энергию порядка \mathcal{E}_g и соответственно имеет большой импульс $\sim \sqrt{2m\mathcal{E}_g}$ (m — его эффективная масса). Вследствие закона сохранения импульса суммарный нач. импульс 3 частиц должен быть достаточно большим, а следовательно, достаточно большой должна быть и их суммарная кинетич. энергия. Этот факт приводит к существованию энергетич. порога оже-Р. Обычно в полупроводниках эфф. масса электрона больше масс дырок ($m_0 \gg m_d$). При этом мин. энергетич. порог оже-Р. $\mathcal{E}_{\text{мин}} = (m_d/m_0) \mathcal{E}_g$ достигается, когда большой импульс вносит тяжёлая дырка. Если тепловая энергия носителей $kT < \mathcal{E}_{\text{мин}}$, то коэф. Р. $\alpha_0 \approx \exp(-\mathcal{E}_{\text{мин}}/kT)$.

Однако в ряде полупроводников благодаря особенностям зонной структуры порог отсутствует. Напр., в GaSb и InAs беспороговым является процесс, в к-ром избыточная энергия уносится дыркой, переходящей из зоны тяжёлых дырок в шишную отщепленную зону (рис. 2). Без порога протекает также оже-Р. с участием примесей или фононов, к-рым может быть передан большой импульс. В непрямозонных полупроводниках оже-Р. возможна только такого типа. Вследствие сильной концентрационной зависимости оже-Р. становится существенной при высокой концентрации свободных носителей. Обычно $\sigma \sim 10^{18} \text{ см}^{-2}$.

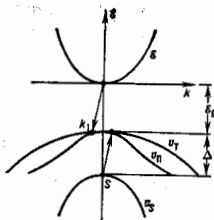


Рис. 2. Оне-рекомбинация, при которой энергия уходит в дырку, которая из своего отщепленной валентной зоны ψ_0 переносится в зону тяглых дырок ψ_1 ; σ — зона проводимости.

$$r_0 = \gamma_0 n N; \quad r_d = \gamma_d p N. \quad (3)$$

Для колич. описания процессов захвата γ_0, γ_d и сечениями захвата на ловушки σ_0, σ_d вводит времена жизни носителей по отношению к захвату на ловушки τ_0 и τ_d :

$$\tau_0^{-1} = \gamma_0 N = \sigma_0 \langle v_0 \rangle N; \quad \tau_d^{-1} = \gamma_d M = \sigma_d \langle v_d \rangle M. \quad (4)$$

Здесь $\langle v_0 \rangle, \langle v_d \rangle$ — ср. тепловые скорости носителей. В простейшем случае ловушек одного типа в сильнотемпер. полупроводниках τ совпадает с временем жизни по отношению к захвату на ловушки неосновных носителей. Так, в полупроводниках p -типа

$$\tau^{-1} \approx \tau_0^{-1} = \sigma_0 \langle v_0 \rangle N.$$

Сечение захвата на примесные центры может изменяться в зависимости от темп-ры и типа примеси в пределах от 10^{-12} см² (притягивающие центры, $T \approx 4,2$ К) до 10^{-22} см² (отталкивающие центры, $T = 300$ К).

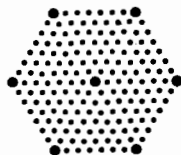
Исследование рекомбинац. процессов в полупроводниках позволяет определить коэф. и сечения Р. и их зависимости от T , эл. поля и параметров полупроводника.

Лит.: Landeberg P. T., Adams M. J., Radiative and Auger processes in semiconductors, «J. of Luminescence», 1973, т. 7, р. 3; Бонч-Бруевич В. Л., Калавичков Г. Г., Физика полупроводников, М., 1977; Абакумов В. Н., Перель В. И., Ясевич И. Н., Захват носителей вярда на притягивающие центры в полупроводниках, «ФТД», 1978, т. 12, с. 3. В. И. Абакумов, И. Н. Ясевич.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ — образование на чистых поверхностях монокристаллов структур, элементарная ячейка и-рых имеет период, отличающийся от периода в объеме кристалла (в параллельных поверхности плоскостях) и обычно превышающий его в неск. раз. Развитие техники сверхвысокого вакуума (давление $p \approx 10^{-10}$ Па) позволило наблюдать атомарно-чистую, свободную от примесей поверхность, полученную скосом и сохраняющуюся неизменной в течение неск. ч.

Большинство исследований выполняется методом дифракции медленных электронов (ДМЭ) [1] или фотоэмиссионными методами [2]. В методе ДМЭ электроны с

Рис. 1. Схема электронограммы от поверхности кремния (111). Интенсивные пятна — рефлексы от объема кристалла; слабые рефлексы, расположенные на расстоянии $1/2$ от расстояния между объемными рефлексами, указывают на периодичность в 2 раз большую соответствующего периода в объеме.



энергиями 1–10 эВ имеют большие сечения рассеяния и глубина их проникновения в кристалл составляет 5–10 Å, т. е. 2–3 монослоя атомов. Схема электронограммы ДМЭ для чистой поверхности кремния (111) приведена на рис. 1. Она свидетельствует о появлении поверхностного периода, в 2 раз превышающего период кристаллич. решетки в объеме. На поверхности образуется сетка размерами (7×7) . В общем случае говорят об образовании сетки $(n \times m)$, где n, m — коэф. пропорциональности между поверхностными и объемными векторами трансляции, θ — угол между поверхностными векторами трансляции. Р. в. наблюдалась также на поверхностях Ge, GaAs, GaSb, InSb, CdS, CdTe, Tl и др. полупроводниковых материялов.

Теоретич. рассмотрение Р. в. основано на квантовом-мех. расч. На свободной поверхности гомополярных кристаллов при сколе образуются обрванные ненасыщенные ковалентные связи. Установление новой равновесной конфигурации поверхностных атомов происходит путем таких их перемещений, к-рые приводят к замыканию обрванных связей и т. о. к понижению энергии системы. При вычислениях полной энергии кристалла размеры поверхностной элементарной ячейки берутся из эксперимента, а характер замыкания связей выбирается модельным способом. На рис. 2 рядом с идеальной реконструированной поверх-

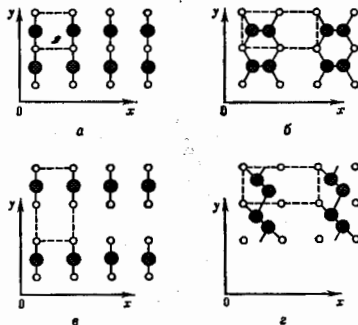


Рис. 3. Поверхностные элементарные ячейки для 3 моделей замыкания обрванных связей на поверхности (100) Si: а — нереконструированная поверхность; каждый атом верхнего слоя (большие кружки) связан 2 гибридными связями с атомами 2-го слоя (маленькие кружки) и имеет две обрванные свободные связи; элементарная ячейка показана пунктиром; б — модель двойных связей (удвоение поверхностной элементарной ячейки по оси $0x$); а — модель с поверхностными связями; на поверхности отсутствуют ряды атомов, оставшихся обрвант свободные связи с атомами 2-го слоя; элементарная ячейка удвояна по $0y$; в — модель цепочек; каждый поверхностный атом имеет 2 одинаковые связи с соседями в цепочке, еще одну связь с атомами 2-го слоя, а оставшиеся 4-и связи делят инд. в молекулярную орбиталь, охватывающую всю цепочку.

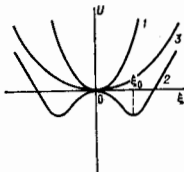
ностью (100) приведены 3 модели разл. замыкания обрванных связей. Сравнение с экспериментом не позволяет отдать предпочтение к.-л. из этих моделей, т. к. расположение дифракц. рефлексов отражает только трансляц. симметрию поверхности. Информация о взаимном расположении атомов в элементарной ячейке содержится в распределении интенсивности в дифракц. рефлексах. Анализ этого распределения является сложной матем. задачей.

Эксперимент показывает, что симметрия поверхности меняется при изменении темп-ры [3], т. е. на поверхности происходит структурные фазовые превращения. Если такое превращение идет по типу фазового

перехода 2-го рода, то можно исследовать устойчивость идеальной поверхности относительно разл. смещений поверхностных атомов из положений равновесия. Любое смещение поверхностного атома можно представить в виде суперпозиции смещений, соответствующих нормальным колебаниям (см. *Колебания кристаллической решетки*). Смещение ξ поверхностного атома из положения равновесия ξ_0 характеризуется волновым вектором q_{\parallel} , параллельным поверхности. Если смещение поверхностного атома приводит к увеличению потенц. энергии U (кривая 1, рис. 3), то исходному состоянию

$$\lambda = 2\pi \left[\left(q_{\parallel}^0 \right)^2 + \left(q_{\perp}^0 \right)^2 \right]^{-1/2} = \sqrt{2} a.$$

Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии U от величин смещения поверхностного атома ξ : кривая 1) соответствует устойчивому равновесию; кривая 2) — эквивалентна с учетом ангармонизма колебаний и соответствует реконструированной поверхности; ξ_0 — новые положения равновесия.



поверхности соответствует минимуму U и поверхность устойчива. Если смещение поверхностных атомов приводит к уменьшению потенц. энергии (кривая 2 вблизи начала координат), то исходное состояние соответствует максимуму потенц. энергии. Поверхность при этом неустойчива, происходит Р. п. Новые положения равновесия ξ_0 определяются ангармонизмом колебаний. С учетом ангармонизма членов $U(\xi)$ имеет вид полной кривой 3.

Условие максимума или минимума потенц. энергии определяется знаком производной $d^2U/d\xi^2$, к-рая пропорц. квадрату частоты поверхностного колебания $\omega^2(q_{\parallel}^0)$. Значение q_{\parallel}^0 , для к-рого $\omega(q_{\parallel}^0) = 0$ (мягкая мода), соответствует колебанию, по отношению к к-рому поверхность неустойчива. Именно q_{\parallel}^0 определяет пространственный период новой устойчивой поверхности конфигурации атомов, соответствующей реконструированной поверхности.

На рис. 4 приведены 2 примера Р. п. (100) кубич. кристалла. Если мягкая мода возникает в точке X

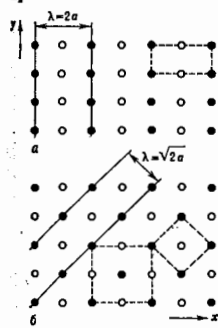


Рис. 4. Примеры реконструированной поверхности (100) кубического кристалла: а — реконструкция за счёт мягкой моды в точке X зоны Бриллюэна; новая элементарная ячейка показана пунктиром; б — реконструкция за счёт мягкой моды в точке M зоны Бриллюэна; новая элементарная ячейка показана пунктиром.

зоны Бриллюэна (см. *Бриллюэна зона*) с координатами $(q_{\parallel}^0 = \pi/a, q_{\perp}^0 = 0)$, то на поверхности устанавливается «волна» статич. смещений с периодом $\lambda = 2\pi/q_{\parallel}^0 = 2a$, где a — период нереконструированной поверхности. Возникают чередующиеся ряды поднявшихся вверх и опустившихся вниз атомов. Происходит удвоение периода решетки вдоль оси x . Если мягкая мода возникает в точке M зоны Бриллюэна с координатами

$$(q_{\parallel}^0 = \pi/a, q_{\perp}^0 = \pi/a),$$

то на поверхности устанавливается волна статических смещений в направлении, составляющем угол 45° с осями Ox и Oy и с периодом

Такую структуру обозначают $(2 \times 2) \sqrt{2} 45^\circ$ или $C(2 \times 2)$.

Возможные перестройки поверхности, происходящие по типу фазового перехода 2-го рода, можно найти тергетико-групповыми методами. Р. п. охватывает неск. прировнекстных кристаллич. плоскостей, составляющих прировнекстный слой [4].

Р. п. с б. большим периодом, напр. структуры (7×7) на поверхности (111) Si, связывают с возникновением узкой энергетич. зоны *поверхностных состояний* для электронов оборванных связей. На поверхности (111) Si на каждый поверхностный атом приходится 1 оборванная связь. Поэтому зона поверхностных состояний заполнена только наполовину. Энергию электрона в такой зоне можно рассчитывать методом сильной связи (см. *Зонаная теория*):

$$\epsilon = \epsilon_0 - 2J \left[\cos p_x a + 2 \cos \frac{p_x a}{2} \cos \frac{\sqrt{3} p_y a}{2} \right].$$

Здесь p_x и p_y — проекции квазиимпульса электрона, J — интеграл перекрытия электронных волновых ф-ций. *Ферми-поверхности* для таких электронов является шестугольным. Из-за наличия плоских граней электр-фононное взаимодействие даёт аномально большой сдвиг частоты нормального колебания с волновым вектором $q_{\parallel} = 2p_{\parallel}$ (p_{\parallel} — импульс Ферми). Если при нек-ром сдвиге частоты результирующая частота $\omega^2(2p_{\parallel}) = 0$, то поверхность кристалла неустойчива относительно такого колебания и произойдет Р. п. Устойчивое состояние соответствует волне статич. смещений с длиной волны $\lambda = 2\pi/q_{\parallel} = \pi/p_{\parallel}$, совмещенной с постоянной решетки $m\lambda = na$, где m и n — целые числа. Период новой структуры определяется числом n . Для поверхности (111) Si число $n = 7$, что соответствует структуре (7×7) .

Исследования атомарно-чистой поверхности важны для понимания свойств границы раздела кристаллов. По-видимому, нач. стадии адсорбции и роста кристаллов (см. *Кристаллизация*) определяются свойствами реконструированных границ раздела [5].

Лит.: 1) Наумов А. Г., Исследование структуры поверхности методом дифракции медленных электронов: достигнени я перспектив, *Эпр. физ. ж.*, 1978, т. 23, № 10, с. 1635; 2) Photoemission and electronic properties of surfaces, ed. by B. Feuerbacher, B. Fitton, R. F. Willis, Chichester — [a.o.], 1978; 3) Oshanevskiy B. Z., Shklyayev A. A., Phase transition on clean Si (110) surface, *Surf. Sci.*, 1977, т. 67, p. 384; 4) Брауэр И. Р., Китчев Ю. Е., Landau theory of second-order phase transitions on solid surfaces, *Prog. in Surf. Sci.*, 1985, т. 18, № 3, p. 189; 5) A d a r t e i t e r G., Inelastic light scattering in semiconductor heterostructures, в кн.: *Результаты физ. науки*, т. 24 — Advances in solid state physics, Braunschweig, 1984. И. П. Игнатова.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — процесс образования и роста (или только роста) структурой более совершенных кристаллич. зёрен *поликристалла* за счёт менее совершенных зёрен той же фазы. Р. начинается при нек-рой темп-ре T_D , к-рая зависит от хим. состава, концентрации дефектов, в частности *дислокаций*. Далее с повышением темп-ры T скорость Р. растёт. Особенно интенсивно она протекает в пластически деформированных материалах (см. *Пластичность*). Зародышными новых зёрен являются дислокац. ячейки.

Различают 3 стадии Р.: первичную, когда в деформиров. материале образуются новые неискажённые зёрна, к-рые растут, поглощая зёрна, искажённые деформацией; собирательную Р. — неискажённые зёрна растут за счёт друг друга, вследствие чего ср. величина зёрна увеличивается; вторичную Р., к-рая отличается от собирательной тем, что способность к росту обладают только немногие из неискажённых зёрен. В ходе вторичной Р. структура характеризуется разл. размерами зёрен. Движению *межзёрных границ* препятствуют дисперсные частицы (размером \sim нм) др. твёрдых фаз (оксидов, карбидов и т. д.) и субмикроросты.

Р. устраняет структурные дефекты, изменяет размеры и ориентацию зёрен и иногда их кристаллографич. ориентацию (текстуру). Р. переводит вещество в состояние с большей термодинамич. устойчивостью: при субрастворной и вторичной Р.— за счёт уменьшения суммарной поверхности границ между зёрнами, при первичной Р.— также за счёт уменьшения искажений, внесенных деформацией. Р. изменяет все структурно-свойствит. свойства материала и часто восстанавливает исходную структуру, текстуру и свойства (до деформации). Иногда структура и текстура после Р. отличаются от исходных, соответственно отличаются и свойства.

Практически важными технол. способами обработки материалов, в к-рых существ. роль играет Р., являются: прокатка, ковка, волочение, экструзия, при к-рых образуются дислокации с плотностью 10^8 — 10^{10} см⁻² и их скопления (ижечная структура); дробление и спекание порошковых (керамич.) материалов, при к-рых образуются субмикронпоры; осаждение поликристаллич. плёнок из газовой фазы или с помощью молекулярных пучков (см. *Эпитаксия*).

Лит.: Горевик С. С., Рекристаллизация металлов и сплавов, 2 изд., М., 1978; Рекристаллизация металлических материалов, под ред. Ф. Хесснера, пер. с англ., М., 1982; Горевик С. С., Бабыч Э. А., Дегтяков Л. М., Формирование микроструктуры и свойств ферритов в процессе рекристаллизации, М., 1984.

РЕКУРРЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ (от лат. recurrens — род, падеж recurrensis — возвращающийся) — однородные ф-лы, к-рые связывают между собой идущие друг за другом элементы нек-рой последовательности (это может быть последовательность чисел, ф-ций и т. д.). В зависимости от природы объектов, связанных Р. с., эти соотношения могут быть алгебраическими, функциональными, дифференциальными, интегральными и т. п.

Наиб. известный класс Р. с. — это рекуррентные ф-лы для специальных функций. Так, для цилиндрич. функций $Z_m(x)$ Р. с. имеют вид

$$Z_{m+1}(x) = \frac{2m}{x} Z_m(x) - Z_{m-1}(x) = \frac{m}{x} Z_m(x) - \frac{d}{dx} Z_m(x) = -x^m \frac{d}{dx} [x^{-m} Z_m(x)].$$

Они позволяют по ф-ции $Z_m(x)$ найти ф-ции $Z_m(x)$ при $m = m_0 \pm 1$, $m_0 \pm 2$ и т. д. либо, напр., по значениям ф-ций Z_{m_0} и Z_{m_0+1} в нек-рой точке $x_0 \neq 0$ найти (в численных расчётах) значение любой из ф-ций Z_m , $m = m_0 - 1, m_0 \pm 2, \dots$ в этой же точке (здесь m_0 — любое вещественное число).

Др. важный класс Р. с. дают многочисленные методы последовательных приближений (см. *Итераций метод*); сюда же примыкают и методы возмущений теор.

В квантовой механике есть ещё один вид Р. с., связывающих между собой векторы в гильбертовом пространстве состояний. Напр., стационарные состояния гармонич. осциллятора параметризуются целыми неотрицательными числами. Соответствующие векторы, обозначаемые $|n\rangle$, где n — целое, при разных n могут быть получены друг из друга действием операторов рождения a^+ и уничтожения a :

$$a^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle,$$

$$a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle.$$

Эти соотношения можно разрешить, выразив любой вектор $|n\rangle$ через $|0\rangle$ (наинищее энергетич. состояние, $n=0$):

$$|n\rangle = \frac{(a^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle.$$

Обобщением этой конструкции является представление вторичного квантования в квантовой статистик.

механике и квантовой теории поля (см. *Фока пространство*).

Типичный пример Р. с. в статистич. механике — ур-ния для частичных ф-ций распределения, образующие цепочку Боголюбова (см. *Боголюбова уравнения*); знание таких ф-ций позволяет найти все термодинамич. характеристики системы.

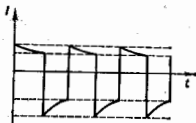
В квантовой теории поля динамич. информация сохраняется, напр., в *Грина функции*. Для их вычисления используют разл. приближения, чаще всего — расчёты по теории возмущений. Альтернативный подход основан на интегродифференциальных *Дайсона уравнениях*, являющихся Р. с.: ур-ние для двухточечной ф-ции Грина содержит четырёхточечную и т. д. Как и ур-ния Боголюбова, эту систему удаётся решить, лишь «оборвав» цепочку (место «обрыва» выбирается обычно из физ. соображений и определяет получаемое приближение).

Ещё один вид Р. с. в квантовой теории поля — *Урда тождества* в теориях калибровочных полей. Эти тождества также представляют собой цепочку интегродифференциальных соотношений, связывающих между собой ф-ции Грина с разл. числом внешних линий, и являются следствием калибровочной инвариантности теории. Решающую роль они играют для проверки калибровочной симметрии при проведении процедуры перенормировки.

Наконец, сама перенормировка — тоже рекуррентная процедура: на каждом шаге (в каждой следующей петле) используются *контрчлены*, полученные из вычисления диаграмм с меньшим числом петель (подробнее см. *Р-операция*).

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ — колебания, возникающие в нелинейных системах, в к-рых существ. роль играют диссипативные силы: внеш. или внутр. трение — в механич. системах, сопротивление — в электрич. системах. Обычно Р. к. говорят применительно к автоколеб. системам. Каждый период Р. к. может быть разделён на нек. резко разграниченных этапов, соответствующих медленным и быстрым изменениям состояния системы, в к-рой происходит Р. к., что позволяет рассматривать Р. к. как разрывные колебания.

Простейший пример электрич. Р. к. — колебания, возникающие в схеме с газоразрядной лампой, к-рая обладает свойством зажигаться при нек-ром напряжении U_2 и гаснуть при более низком напряжении U_1 . В этой схеме периодич. осуществляется зарядка конденсатора C от источника тока E через сопротивление R до напряжения зажигания лампы, после чего лампа зажигается и конденсатор быстро разряжается через лампу до напряжения гашения лампы. В этот момент лампа гаснет и процесс начинается вновь. В течение каждого



периода этих Р. к. происходят два медленных изменения силы тока I при заряде и разряде конденсатора и два быстрых — скачкообразных — изменения тока I_c , когда лампа зажигается и гаснет (рис.).

Упрощённое рассмотрение механизма возникновения Р. к. основано на пренебрежении параметрами системы, влияющими на характер быстрых движений. Методы нелинейной теории колебаний позволяют исследовать не только медленные, но и быстрые движения, не пренебрегая параметрами, от к-рых характер быстрых движений существенно зависит, и не прибегая к спец. постулатам о характере быстрых движений. В зависимо-

сти от свойств системы возможно большое разнообразие форм P , к. от близких к гармоническим до скачкообразных и импульсных.

Электрич. P , к. применяются в измерит. технике, телеуправлении, автоматике и др. разделах электроники. Для их создания существуют разнообразие генераторы P , к., напр. *блочки-генераторы, мультициклогенераторы, генераторы РС*.

Лит.: Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э., Теория колебаний, 2 изд., М., 1981; Морозов Л. А., Зеличенко Л. Г., Импульсная техника, 2 изд., М., 1974, гл. 14; Качинский И. М., Методы теории колебаний в радиоэлектронике, М., 1984.

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР (генератор релаксационных колебаний) — генератор электромагнитных колебаний, в которых процесс колебаний имеет место лишь поочередно относительно небольших потерь энергии, в P , г. энергия, запасаемая в реактивном элементе, в процессе каждого периода колебаний расходуется полностью или почти полностью, а затем возобновляется за счёт источника питания и нелинейных активных элементов (электронных ламп, транзисторов, диодов). Период колебаний при этом определяется временем релаксации (установления равновесия) в цепях генератора (см. *Релаксационные колебания*).

P , г. относятся к *мультигенераторам* разных типов, генераторы скачкообразного напряжения, блочки-генераторы и др. Форма колебаний, генерируемых P , г., может быть различной. Так, если P , г. имеет только одну степень свободы (т. е. его поведение описывается одним дифференц. ур-нием 1-го порядка), то процессы в нём имеют характер *разрывных колебаний*, при к-рых медленные изменения состояний системы чередуются со скачкообразными изменениями переменной величины или направления хода процесса в системе. Скорость этих скачкообразных изменений ограничивается лишь величиной паразитных параметров. P , г., имеющие неск. степеней свободы, могут генерировать разл. типы непрерывных колебаний. Подбором параметров цепи генератора можно создать P , г., в к-ром возбуждаются колебания, близкие к гармоническим (см. *Генератор РС*). Такие генераторы широко используются в качестве источников колебаний звуковых и инфразвуковых частот (от 200 кГц до долей Гц).

Лит.: см. ст. Генератор электромагнитных колебаний. В. В. Мухомин.

РЕЛАКСАЦИЯ (от лат. relaxatio — ослабление, уменьшение) — процесс установления статистич. (а следовательно, и термодинамич.) равновесия в физ. системе, состоящей из большого числа частиц. P . — многоступенчатый процесс, т. к. не все физ. параметры системы (распределение частиц по координатам и импульсам, темп-ра, давление, концентрация вещества в малых объёмах и во всей системе и др.) стремятся к равновесию с одинаковой скоростью. Обычно сначала устанавливается равновесие по к.-л. параметру (частичное равновесие), что также наз. P . Все процессы P . являются неравновесными и необратимыми процессами, при к-рых в системе происходит диссипация энергии, т. е. производится энтропия (в замкнутой системе энтропия возрастает); исследование этих процессов составляет предмет *кинетич. физич. физики*. В разл. системах P . имеет свои особенности, поэтому процессы P . весьма многообразны. Время t установления (частичного или полного) равновесия в системе наз. *временем релаксации*. Когда отклонение от равновесия невелико, P . параметра u обычно происходит по закону $u = u_0 \exp(-t/\tau)$, где u_0 — нач. значение параметра u .

В экспериментах P . проявляется косвенно: по затуханию макроскопич. движений, возникающих под действием внеш. сил, и по частотной зависимости кинетич. коэффициентов. Эфф. уменьшение внеш.

воздействия с ростом частоты ω приводит обычно к немонотонной зависимости от ω периодичной за период энергии, $Q(\omega) \approx \omega(t)(1 + \omega^2 \tau^2)^{-1}$. Наличие максимума у величины $Q(\omega)$ при $\omega t = 1$ наз. кинематич. (релаксационный резонанс). Наличие неск. максимумов свидетельствует о существовании неск. механизмов P . Если в системе наблюдается резонансное поглощение энергии, то ширина резонансной кривой пропорц. τ^{-1} .

В газах процесс установления равновесия определяется *длиной свободного пробега l* и временем свободного пробега $t_{\text{пр}}$ (ср. расстояние и ср. время между двумя последовательными столкновениями частиц). Отношение $l/t_{\text{пр}}$ равно по порядку величин ср. скорости частиц (по абс. значению). Величины l и $t_{\text{пр}}$ малы по сравнению с макроскопич. масштабами длины и времени. С др. стороны, для газов время свободного пробега значительно больше времени столкновения частиц τ_0 ($t_{\text{пр}} \gg \tau_0$). Только при этом условии P . определяется лишь парными столкновениями частиц (см. также *Кинетическая теория газов*).

В одноатомных газах (без внутр. степеней свободы) P . происходит в два этапа. На первом этапе за короткий промежуток времени, порядка времени столкновения частиц τ_0 , начальное (даже сильно неравновесное) состояние хаотизируется так, что становятся несущественными детали нач. состояния и оказываются возможным т. н. «сокращённое» описание неравновесного состояния системы, когда не требуется знания вероятности распределения всех частиц системы по координатам и импульсам, а достаточно знать одночастичную *функцию распределения*. (Все остальные ф-ции распределения более высокого порядка, описывающие распределение по состояниям двух, трёх и т. д. частиц, зависят от времени лишь через одночастичную ф-цию). Одночастичная ф-ция распределения удовлетворяет *кинетическому уравнению Больцмана*, к-рое описывает процесс её P . Эта стадия P . наз. кинетической и является очень быстрым процессом.

На второй стадии P . за время порядка времени свободного пробега частиц $t_{\text{пр}}$ в результате всего неск. столкновений в макроскопич. малых объёмах системы, движущихся с массовой скоростью (ср. скорость переноса массы), устанавливается *локальное термодинамическое равновесие*, ему соответствует локально-равновесное, или квазиравновесное, распределение, к-рое характеризуется такими же параметрами, как и при полном равновесии системы (темп-ра и хим. потенциалом), но зависящими от пространственных координат и времени. Эти малые объёмы содержат ещё очень много частиц, а поскольку они взаимодействуют с окружающей средой лишь через частицы, близкие своей поверхности, их можно считать приблизительно изолированными. Параметры локально-равновесного распределения в процессе P . медленно (по сравнению с кинетич. стадией P .) стремятся к равновесным значениям, а состояние системы мало отличается от равновесного, если градиенты термодинамич. параметров малы. Время P . для локального равновесия $t \approx t_{\text{пр}}$. После установления локального равновесия для описания P . используют ур-ния гидродинамики с учётом неоднородности темп-ры и концентрации (*Наве — Стокса уравнения*, ур-ния теплопроводности, диффузии и др.). При этом предполагается, что термодинамич. параметры (плотность, темп-ра и массовая скорость) мало меняются за время $t_{\text{пр}}$ и на расстоянии l . Эта стадия P . наз. гидродинамической. Процесс P . системы к состоянию полного статистич. равновесия происходит медленно, после большого числа столкновений, поэтому процессы теплопроводности, диффузии, вязкости и т. п. являются медленными процессами. Соответственно время P . т. аванс от размеров L системы и велико по сравнению с $t_{\text{пр}}$: $t \approx t_{\text{пр}}(L/l)^2 \gg t_{\text{пр}}$, что имеет место при $l \ll L$, т. е. не для сильно разреженных газов.

В многоатомных газах (с внутр. степенями свободы) может быть замедлен обмен энергией между поступат. и внутр. степенями свободы и возникает процесс P , связанный с этим явлением. Быстрее всего (за время порядка времени между столкновениями) устанавливается равновесие по поступат. степеням свободы, к-рое можно охарактеризовать соответствующей темп-рой. Равновесие между поступат. и вращат. степенями свободы устанавливается значительно медленнее. Возбуждение колебат. степеней свободы может происходить лишь при высоких темп-рах. Поэтому в многоатомных газах для энергии вращат. и колебат. степеней свободы возможны многоступенчатые процессы. В многоатомных газах P внутр. степеней свободы вызывает появление объёмной вязкости, к-рой нет в одноатомных газах.

В смесях газов с сильно различающимися массами частиц замедлен обмен энергией между компонентами, вследствие чего возможны появление состояния с разл. темп-рами компонент и процессы P их темп-р. Напр., в плазме сильно различаются массы ионов и электронов. Быстрее всего устанавливается равновесие электронной компоненты, затем приходит в равновесие ионная компонента, и значительно большее время требуется для установления равновесия между электронами и ионами. Поэтому в плазме могут длит. время существовать состояния, в к-рых ионные и электронные темп-ры различны, следовательно, происходит медленные процессы P темп-р компонент (см. *Релаксация компонент плазмы*).

В жидкостях терют смысл понятия времени и длины свободного пробега частиц (всперимимо кинетич. урние Больцмана для одночастичной ф-ции распределения). Аналогичную роль для жидкостей играют величины τ_1 и l_1 — время и длина затухания пространственно-временных *корреляционных функций* динамики, перемещения, описывающих потоки энергии и импульса; τ_1 и l_1 характеризуют затухание во времени и пространстве взаимного влияния молекул, т. е. корреляций. Для жидкостей полностью остаётся в силе понятие гидродинамич. зтапа P и локально-равновесного состояния. В макроскопически малых объёмах жидкости, но ещё достаточно больших по сравнению с длиной корреляции l_1 локально-равновесное распределение устанавливается за время порядка времени корреляции τ_1 ($\tau \approx \tau_1$) в результате интенсивного взаимодействия между частицами (а не только парных столкновений, как в газе); эти объёмы по-прежнему можно считать приблизительно изолитрованными. На гидродинамич. зтапе P в жидкости термодинамич. параметры и массовая скорость удовлетворяют таким же ур-ниям гидродинамич. теплопроводности и диффузии, как и для газов (при условии малости изменения термодинамич. параметров и массовой скорости за время τ_1 и на расстояниях l_1).

Время P к полному термодинамич. равновесию в объёме L^3 , $\tau \approx \tau_1(L/l_1)^3$ (так же, как в газе и твёрдом теле), можно оценить с помощью кинетич. коэффициентов. Напр., время P концентрации в бинарной смеси порядка $\tau \approx L^2/D$, где D — коэф. диффузии; время P темп-ры $\tau \approx L^2/\chi$, где χ — коэф. температуропроводности, и т. д. Для жидкости с внутр. степенями свободы у частиц (молекул) возможно сочетание гидродинамич. описания с дополнит. ур-ниями для описания P внутр. степеней свободы (релаксационная гидродинамика).

В твёрдых телах, как и в *квантовых жидкостях*, P можно описывать как P в газе *квазичастиц*. В этом случае можно ввести время и длину свободного пробега соответствующих квазичастиц (при условии малости возбуждения системы). Напр., в кристаллах решётке при низких темп-рах упругие колебания можно трактовать как газ фононов. P внутр. энергии в кристаллич. решётке описывается кинетич. ур-нием для фононов.

В системе спиновых магн. моментов ферромагнетич. квазичастицами являются *магноны*, P намагнитичности (см. *Релаксация магнитная*) можно описывать кинетич. ур-ниями для них.

P , обусловленная распространением звуковых волн в веществе, с к-рой связано поглощение звука, на *релаксационной акустической*.

При фазовых переходах P может иметь сложный характер. Если переход из неравновесного состояния в равновесное является фазовым переходом 1-го рода, то система сначала переходит в *метастабильное состояние*. P из метастабильного состояния в стабильное может оказаться настолько медленным процессом, что метастабильное состояние можно рассматривать как равновесное (см. *Стеклообразное состояние*).

Вблизи точки фазового перехода 2-го рода параметр порядка, характеризующий степень упорядоченности фаз, стремится к 0, а его время P сильно увеличивается (см. *Кинетика фазовых переходов*).

Ещё сложнее характер P в системах, далёких от термодинамич. равновесия. Так, в *открытых системах* возможно появление стационарных состояний, обладающих пространственной или временной когерентностью (см. *Неравновесные фазовые переходы*).

Лит. см. при ст. *Кинетика физического*. Д. Н. Зубарев. **РЕЛАКСАЦИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ** — процесс восстановления термодинамич. равновесия среды, к-рое было нарушено из-за изменения давления и темп-ры при прохождении звуковой волны. P а. — необратимый процесс, при к-ром энергия поступат. движения молекул или ионов в звуковой волне переходит на внутр. степени свободы, возбуждая их, в результате чего энергия звуковой волны уменьшается, т. е. происходит *поглощение звука*. P а. также всегда сопровождается *дисперсией звука*.

Простейший вид P а. — релаксация внутримолекулярного возбуждения, или *кнезеровой релаксации*. Такая P а. происходит, напр., в двухатомных и многоатомных газах, где энергия поступат. движения молекул в звуковой волне переходит в энергию, связанную с колебат. и вращат. степенями свободы молекул, т. е. изменяется заселённость вращат. и колебат. уровней. Др. виды P а.: структурная релаксация в жидкостях, при к-рой акустич. волна инициирует изменение ближнего порядка в расположении молекул жидкости; хим. релаксация, при к-рой под действием звука сдвигается равновесие в хим. реакции. В твёрдом теле звуковая волна нарушает равновесное распределение фононов, что приводит к релаксационным процессам, определяющим *решётчное поглощение звука*. Один из видов P а. в твёрдом теле — релаксация разл. *дефектов* кристаллической решётки — как точечных, так и линейных (*дислокаций*), связанная с движением дефектов под действием механич. напряжений в упругой волне. При распространении звука в полупроводниках и металлах нарушается равновесное распределение электронов проводимости, что также приводит к релаксации, а следовательно, к дополнит. поглощению звука.

Для описания отклонения системы от равновесия вводят дополнит. параметр ξ , к-рый в зависимости от вида релаксационного процесса может иметь разл. физ. смысл (напр., величина ξ может описывать отклонение концентрации возбуждённых молекул от равновесной, изменение заселённости уровней для двухуровневой системы, концентрация одного из компонентов хим. реакции при хим. релаксации и т. н.). Для описания распространения звука в среде с релаксацией рассматриваются как «внеш.» параметры, такие, как давление, плотность и темп-ра, так и «внутр.» параметр ξ , изменение к-рого со временем описывается ур-нием

$$\frac{d\xi}{dt} = -\frac{1}{\tau}(\xi - \xi_0), \quad (1)$$

где τ — время релаксации, ξ_0 — равновесное значение параметра ξ .

Звуковое давление p в акустич. волне, распространяющейся в среде с релаксацией, оказывается равным сумме давления p_0 , обусловленного только изменением плотности, и добавочного давления p_p , возникающего из-за наличия релаксационного процесса. Это добавочное давление сдвинуто по фазе относительно изменения плотности, что приводит к дополнит. (релаксационн.) поглощению звука. Из решения ур-ния (1) для гармонич. волны можно видеть, что при разных частотах звука отклонение ξ от равновесного значения различно, поэтому добавочное давление при том же изменении плотности оказывается разным при разных частотах. Соответственно скорость звука $c = (\partial p / \partial \rho)^{1/2}$ также зависит от частоты, т. е. за счёт Р. а. возникает дисперсия скорости звука. Изменение c с частотой происходит от макс. значения c_∞ на высоких частотах ($\omega \gg 1$), когда процесс установления равновесия не успевает за изменениями плотности, до мин. значения c_0 на низких частотах, когда равновесие полностью успевает установиться при колебаниях плотности и избыточное давление $p_p = 0$.

Учёт релаксации при распространении звука эквивалентен введению комплексной сжимаемости. Волновое число звуковой волны k связано с частотой ω соотношением

$$k^2 = \omega^2 \frac{1 - i\omega\tau}{c_0^2 - c_\infty^2 + i\omega\tau}$$

Скорость звуковой волны и соответствующий коэф. релаксационн. поглощения α_p в зависимости от частоты выражаются приближёнными формулами

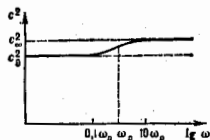
$$c^2 = c_0^2 \left[1 + \frac{c_\infty^2 - c_0^2}{c_0^2} \cdot \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \right], \quad (2)$$

$$\alpha_p = \frac{c_\infty^2 - c_0^2}{2c_0^2} \cdot \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2}, \quad (3)$$

если поглощение звука на длине волны мало ($\alpha_p \lambda \ll 1$) и дисперсия скорости звука невелика, т. е. $c_\infty - c_0 \ll c_0$, как это имеет место для большинства релаксационн. процессов. Скорость звука и коэф. поглощения звука в среде с релаксацией связаны между собой Крамера — Кронига соотношением.

Зависимости скорости звука и коэф. поглощения от частоты для одного релаксационн. процесса имеют универсальный характер независимо от физ. механизма, к-рый лежит в основе Р. а. (рис. 1 и 2). Влияние Р. а. на по-

Рис. 1. Зависимость квадрата скорости звука c^2 от частоты ω для одного релаксационного процесса, $\omega_p = 1/\tau$.

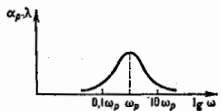


глошение и скорость звука зависит от соотношения между периодом волны и временем релаксации, т. е. от величины отн. к-ра характеризует степень восстановления равновесия. Чем меньше $\omega\tau$, тем полнее равновесие успевает восстановиться за период волны. На малых частотах, т. е. при $\omega\tau \ll 1$, добавочное поглощение может быть описано введением *объемной* вязкости с эфф. значением коэф. объемной вязкости $k_{эф} = \rho(c_\infty^2 - c_0^2)$. При этом коэф. поглощения пропорц. ω^2 , а скорость звука равна c_0 . На больших частотах при $\omega\tau \gg 1$ равновесие не успевает восстановиться за период звуковой

волны и коэф. поглощения звука стремится к пост. величине, равной $\alpha_p = (c_\infty^2 - c_0^2)/2\tau c_0^2$. При $\omega\tau = 1$ коэф. поглощения, умноженный на длину волны, имеет максимум, равный $\alpha_p \lambda = \pi(c_\infty^2 - c_0^2)/2c_0^2$. Т. о., величина дисперс. скачка $\epsilon = (c_\infty^2 - c_0^2)/c_0^2$ и поглощение на длине волны при $\omega\tau = 1$ различаются в 1 раз для любых сред. Определяя величины ϵ и τ на измерений поглощения и скорости звука, можно установить параметры, характеризующие релаксационн. процесс (акустич. спектроскопия), а также определять такие свойства вещества, как теплоёмкость, постоянная Грюнайена и др.

Ввиду большой ширины дисперс. области (более двух порядков по частоте) для акустич. определения величины ϵ и τ нужно проводить измерения c и α_p в широком интервале частот по обе стороны частоты релаксации $\omega_p = 1/\tau$. На практике релаксационн. поглощение звука накладывается на обычное поглощение, обусловленное вязкостью и теплопроводностью, поэтому акустич. кривые для $\alpha_p \lambda$ не имеют таких ярко выраженных максимумов, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость коэффициента релаксационного поглощения звука α_p на длину волны λ от круговой частоты ω .



Для получения кривых релаксационн. поглощения необходимо исключить вклад др. видов поглощения. Если неск. релаксационн. процессов сильно различаются по времени релаксации, то дисперс. области разделяются (рис. 3), а если времена релаксации близки друг к другу, то вид релаксационн. кривых усложняется.

Большинство механизмов Р. а. с $\tau \leq 10^{-8}$ с проявляется только при объёмных деформациях и даёт вклад в объёмную вязкость. В жидкостях и твёрдых телах, однако, за счёт структурной релаксации возможна зависимость от частоты и для сдвиговой вязкости. В маловязких жидкостях (вода и др.) она возникает на очень высоких частотах ($\omega \sim 10^{10}$ с⁻¹), а в жидкостях с большой вязкостью (напр., в масле) такая зависимость наблюдалась экспериментально.

Время релаксации τ характеризует то время, за в-рое параметр ξ , описывающий отклонение системы от равновесия, уменьшится в e раз: $\xi - \xi_0 = \xi_0 \exp(-t/\tau)$. Время релаксации зависит от микроскопич. свойств вещества, таких, напр., как число соударений молекул газа в единицу времени и эффективность передачи энергии при этих соударениях. В газе при заданной темп-ре время релаксации прямо пропорционально числу соударений, необходимых для возбуждения соответствующих степеней свободы. Напр., при нормальных условиях в газе для возбуждения вращат. степеней свободы молекул обычно достаточно 100 соударений, а для возбуждения колебат. степеней свободы нужно $10^3 - 10^6$ соударений. Это означает, что величина τ для колебат. релаксации гораздо больше, чем для вращательной. Время релаксации зависит от давления и темп-ры. Так, в газах обычно $\tau \sim 1/P$, где P — давле-

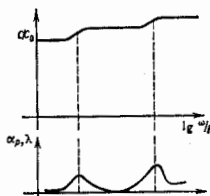


Рис. 3. Зависимость нормированной скорости звука c/c_0 и коэффициента релаксационного поглощения $\alpha_p \lambda$ на длину волны λ от частоты ω отнесённой к давлению газа P , при наличии двух релаксационных процессов.

ние газа. Поэтому релаксация, кривые для газов обычно изображаются как ф-ция величины ω/P . Это позволяет при эксперим. определении зависимости α_p и с от ω изменять давление газа, а не частоту звука, что сильно упрощает измерения. В многоатомных газах обычно преобладает колебат. релаксация. Области частот, в к-рых проявляются колеб. и вращат. релаксации, обычно чётко разделяются, т. к. времена релаксации для этих двух процессов различаются на неск. порядков. Наличие примесей др. газов влияет на время релаксации. Напр., в воздухе осн. вклад в поглощение звука даёт колебат. релаксация молекул O_2 и N_2 , причём частота релаксации для O_2 выше, чем для N_2 . Присеи паров воды и изменение темп-ры воздуха существенно влияют на положение релаксац. максимума. В двухатомных газах значения τ обычно очень велики и область релаксации лежит в звуковом диапазоне частот. Для более сложных газов частота ω_p выше (порядка 10^8 — 10^7 Гц при давлении 1 атм).

В жидкостях времена релаксации значительно меньше, чем в газах, т. к. все процессы перестройки жидкостей совершаются быстрее. Поэтому в большинстве жидкостей частота P а. лежит в области гиперзвука.

В твёрдых диэлектриках при отклонении системы фононов от равновесия время релаксации связано с временем жизни фононов $\tau_0 = 3\kappa/CS^2$, где κ — коэф. теплопроводности, S — теплоёмкость решётки, c — ср. значение скорости звука, $\tau_0 \sim 1/T$ при темп-ре T порядка и выше дебаевского. При распространении звука в пьезополимерных частота релаксации ω_p растёт с ростом проводимости кристалла и уменьшается с ростом темп-ры и подвижности носителей тока, а величина дисперсии скорости звука определяется коэф. электромеханич. связи. Дислокац. поглощение звука в монокристаллах также имеет релаксац. характер, причём время релаксации зависит от длины колеблющегося отрезка дислокации, вектора Бюргера и постановки решётки. Релаксац. процессы имеют место также в полимерах, резинах и разл. вязкоупругих средах, в этих веществах наблюдается значит. дисперсия скорости звука, связанная с релаксацией механизма высокой эластичности.

Лит.: Мандельштам Л. И., Леонитович М. А., К теория поглощения звука в жидкостях, «ЖЭТФ», 1937, т. 7, в. 3, с. 438; Михалев И. Р., Соловьев В. А., Смирнов Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964; Физическая акустика, под ред. У. Мэсона, пер. с англ., т. 2, ч. А и В, М., 1968—69; Herzfeld К. F., Litovitz T. A., Absorption and dispersion of ultrasonic waves, N. Y.—L., 1959.

А. Д. Полякова.

РЕЛАКСАЦИЯ КОМПОНЕНТ ПЛАЗМЫ — процесс изменения функций распределения заряд. частиц в плазме за счёт столкновений при стремлении их к равновесию термодинамическому, приводящий к установлению максвелловского распределения.

В простой полностью ионизованной плазме, состоящей из электронов и ионов одного сорта, времена обмена импульсом и энергией при кулоновских столкновениях частиц одного знака между собой и с др. частицами существенно различны. Времена обмена импульсом и энергией при столкновениях одинаковых частиц есть величины одного порядка и даются выражением:

$$\tau_{ij} = 3m_i^{1/2} T_j^{3/2} / 4\sqrt{2\pi} A e^4 n_j^2 Z_j^4,$$

где A — кулоновский логарифм, Z_j — зарядовое число, n_j — концентрация, T_j — темп-ра. При этом для сравн. велич темп-р $T_e \sim T_i$ релаксация импульса и энергии электронов происходит значительно быстрее: $\tau_{ee} \sim \tau_{ei}(m_e/m_i)^{1/2}$. Передача импульса при столкновениях электронов с ионами характеризуется временем $\tau_{ei}^* \sim \tau_{ee}$, а обмен энергией происходит за значительно большее время $\tau_{ei}^{**} \sim \tau_{ei}^* m_i/m_e$. Поэтому часто встреча-

ется ситуация, когда распределения электронов и ионов близки к максвелловским, но $T_e \neq T_i$, т. е. плазма двухтемпературна (частичное равновесие).

В слабоконтролизованной плазме время релаксации импульса электронов при столкновениях с атомами $\tau_{ea}^* \sim \tau_{ea}$, где ν_{ea} — частота столкновений, а время релаксации энергии при упругих столкновениях $\tau_{ea}^{**} = m_e/2m_a \nu_{ea}$. Неупругие столкновения могут приводить к гораздо более быстрой релаксации распределения электронов в нек-рых областях энергии. Так, напр., в газовых разрядах электроны с энергией, превышающей первый потенциал возбуждения, релаксируют по энергии быстрее, чем тепловые, для к-рых характерное время есть τ_{ea}^{**} .

Релаксация пучка пробных частиц в полностью ионизованной плазме описывается Фоккера — Планка уравнением. При этом происходит как торможение пучка за счёт динамич. трения, так и размытие пучка по скоростям — диффузия в пространстве скоростей. Для быстрых частиц время релаксации определяется их энергией, поэтому хвосты ф-ции распределения релаксируют значительно медленнее, чем тепловые частицы. Торможение и рассеяние пучка быстрых электронов с энергией ϵ происходит как на ионах, так и на электронах практически с одним и тем же характерным временем

$$\tau_{ej} = m_i^{1/2} \epsilon^{3/2} / \pi \sqrt{2} A n_j Z_j^4 e^4.$$

Ионы же с очень большой энергией $\epsilon > (m_e/m_i) T_i$ тормозятся на электронах с характерным временем $\tau_{ie}^* = (m_e/m_i)^{1/2} \tau_{ei}$, почти не рассеиваясь. В обратном случае релаксация пучка ионов по энергии и по импульсу происходит за счёт нон-нонных столкновений со временем

$$\tau_{ii} = m_i^{1/2} \epsilon^{3/2} / \pi \sqrt{2} A n_i Z_i^4 e^4.$$

В плазме с редкими столкновениями релаксация пучка может происходить гораздо быстрее, чем столкновительная, за счёт генерации волн в результате развития пучковой неустойчивости и последующего торможения и рассеяния частиц на возникающих при этом волнах.

Лит.: Трубиных В. А., Столкновения частиц в полностью ионизованной плазме, в сб.: Вопросы теории плазмы, в. 1, М., 1963; Хитон Ф., Явления переноса в столкновительной плазме, пер. с англ., в кн.: Основы физики плазмы, т. 1, М., 1963; В. А. Рожновский, Л. Д. Ценкин.

РЕЛАКСАЦИЯ МАГНИТНАЯ — процесс установления термодинамич. равновесия в системе магн. моментов вещества. Как правило, Р. м. — сложный, многоступенчатый процесс; его характеризуют разл. временами релаксации (см. также Релаксация).

Магн. свойства вещества (за исключением диамагнетиков) обусловлены микроскопич. магн. моментами, к-рые обычно связаны со спином электронов и ядер и образуют т. н. магн., или спиновую, систему (СС). Энергия СС складывается из её взаимодействия с внеш. магн. полем H (зеемановская энергия, см. Зееман эффект), внутрискристаллическим полем и между самими микроскопич. моментами (энергия спин-спинового взаимодействия). Р. м. при к-рой полная энергия СС не меняется, а лишь перераспределяется между степенями свободы магн. моментов, наз. спиновой. Р. м., изменяющая полную энергию СС, наз. с. и н. р. с. и т. о. й. Она устанавливает равновесие между СС и термостатом (кренштейн); последний термин часто не ограничивают случаем решётки кристалла, а имеют в виду все степени свободы, кроме ориентации спинов (тепловое движение молекул жидкости, электронов (проводимости в металле и пр.).

Парамагнетизм. Равновесное состояние парамагнетика, находящегося при т-ре T во внеш. магн. поле H ,

соответствует равновесное значение его намагниченности M_0 , направленной, как правило, по H (см. *Парамагнетизм*). Любое изменение величины или направления поля H приводит к Р. м., в процессе к-рой M стремится к своему новому равновесному значению. При этом релаксация продольной (M_1) и поперечной (M_2) по отношению к H составляющих вектора намагниченности происходит с разной скоростью. Соответственно различают время продольной релаксации τ_1 и время поперечной релаксации τ_2 , как правило, $\tau_1 > \tau_2$. Во мн. случаях оба вида релаксации можно описать феноменологич. ур-нием, полученным Ф. Блохом (F. Bloch, 1946):

$$\frac{dM}{dt} = \gamma[MH] - i \frac{M_x}{\tau_1} - j \frac{M_y}{\tau_2} - k \frac{M_z - M_0}{\tau_1}, \quad (1)$$

где γ — магнито-механическое отношение для носителей магнетизма (электронов или ядер); i, j, k — единичные векторы осей x, y, z ; поле H направлено вдоль оси z . Первое слагаемое в правой части (1) описывает прецессию вектора M вокруг направления H с частотой $\omega_0 = \gamma H$ (см. *Лармора прецессия*). Второе и третье слагаемые соответствуют поперечной релаксации. Её причиной является расфазировка (нарушение когерентности фаз) прецессии отд. микроскопич. моментов вещества, приводящая к асинхрон. затуханию M_1 с временем τ_2 . Источником поперечной релаксации могут быть как спин-спиновые, так и спин-решёточные взаимодействия, в зависимости от того, какие из них эффективнее. Др. причиной затухания могут быть разл. статические неоднородности (напр., неоднородности внеш. поля H), вызывающие разброс частот прецессии индивидуальных спинов. В этом случае поперечная релаксация обратима (см. *Спиновые эхо*). В электронных парамагнетиках время τ_2 попадает в диапазон от 10^{-9} с (неразбавлённые парамаг. соли) до 10^{-3} – 10^{-4} с (диамагн. кристаллы с примесью парамагн. ионов), для ядерных спиновых систем — от 10^{-4} с (твёрдые тела) до секунд (жидкости). В последнем случае замедление релаксации обусловлено усреднением анизотропных спиновых взаимодействий из-за быстрого теплового движения молекул.

Последнее слагаемое в ур-нии (1) описывает продольную релаксацию. В достаточ. больших магн. полях она обусловлена спин-решёточным взаимодействием и ведёт к равновесному распределению спинов по земановским уровням энергии за время $\tau_1 > \tau_2$. В малых полях продольная релаксация может быть спин-спиновой, причём $\tau_1 \sim \tau_2$.

Во мн. случаях описание Р. м. с помощью ур-ния (1) неадекватно. В частности, в твёрдых неспродвижных парамагнетиках (как электронных, так и ядерных) при $\tau_1 > \tau_2$ Р. м. протекает сложнее. Она ведёт к установлению в СС внутр. квазиравновесия, при к-ром всемагнетик и спин-спиновая подсистема характеризуются собственными спиновыми температурами. Их выравнивание между собой и с темп-рой решётки T происходит на след. этапе, за счёт спин-решёточного взаимодействия. Дополнит. осложнения Р. м. возникают из-за мультишпелетной структуры ниж. энергетич. уровней парамаг. ионов в кристаллич. поле, сверхтонкого взаимодействия электронов с ядрами и др.

Конкретные механизмы спин-решёточной релаксации и парамагнетиках многообразны, однако в любом случае в их основе лежит воздействие на СС флуктуирующих полей, создаваемых тепловым движением решётки (см. *Спин-фононное взаимодействие*). Частотный спектр спин-решёточного взаимодействия содержит характерные частоты СС (в частности, ω_0). В концентрированных электронных парамагнетиках это обеспечивается модуляцией дипольных и обменных взаимодействий между магн. ионами тепловыми колебаниями решётки или молекулярным движением. В твёрдых телах с малой концентрацией парамагн. примесей (ионов переходных групп, свободных радикалов и т. п.) осн. роль играет

модуляция орбитального движения несвязанных электронов, передающаяся спиновым степеням свободы через спин-орбитальное взаимодействие. Потому наиб. быстрая спин-решёточная релаксация наблюдается для ионов, в магнетизме к-рых существует вклад орбитального движения (Fe^{2+} , Cr^{2+} и др.), а наиб. медленная — для прим. спинового магнетизма (Mn^{2+} , водорододобные дефекты и др.).

Элементарные процессы спин-решёточной релаксации могут быть прямыми (с рождением или поглощением одного фонона частоты ω_0), комбинированными (двухфононными), а также многоступенчатыми, с участием ближайших возбуждённых состояний. Прямые процессы преобладают лишь при низких темп-рах, где обычно $\tau_1 \sim 1/T$. Остальные механизмы, характерные для более высоких темп-р, ведут к более сильной (стенной, экспоненциальной) температурной зависимости τ_1 . Диапазон значений τ_1 в электронных парамагнетиках от 10^{-9} – 10^{-7} с при комнатной темп-ре до 10^{-3} – 1 с при темп-рах نزدیک гелия.

Ядерная спин-решёточная релаксация обычно обусловлена влиянием парамагн. ионов (примесных, если осн. решётка диамагнетична), сверхтонкого взаимодействия с к-рыми обеспечивает передачу энергии от ядерных спинов к решётке. В металлах и полупроводниках аналогичную роль посредника играют электроны проводимости. Прямое воздействие колебаний решётки твёрдого тела бывает существенным лишь для ядер, обладающих электрическим квадрупольным моментом ядра (см. *Ядерный квадрупольный резонанс*). В жидкостях и молекулярных соединениях, где реализуется быстрое движение молекул или их фрагментов, эффективен механизм модуляции ядерных диполь-дипольных взаимодействий; этот эффект лежит в основе методов изучения молекулярной подвижности с помощью Р. м. Типичные значения τ_1 для ядер от 10^{-4} до 2 часов.

Магнитоупорядоченные вещества. Сильное обменное взаимодействие между электронами в ферро-, ферри- или антиферромагнетиках, заставляющее их спины поддерживать определ. ориентацию по отношению друг к другу, приводит к коллективизации процессов Р. м. При этом устанавливается равновесное распределение энергии между собой, типами коллективных колебаний магн. системы: однородной прецессией намагниченности, неоднородными типами прецессии, спиновыми волнами, а также между магн. системой и решёткой.

В простейших случаях Р. м. в ферромагнетике можно описать как затухание прецессии вектора M вокруг направления эфф. поля: $H_{эфф.} = H + H_A$, где H_A — поле анизотропии (см. *Магнитная анизотропия*), связанное с осью лёгкого намагничивания. На практике часто используют феноменологич. *Ландау — Лифшица уравнение*, к-рое можно записать в виде

$$\frac{dM}{dt} = \gamma[MH_{эфф.}] - \frac{\lambda}{M^2} [M[MH_{эфф.}]]. \quad (2)$$

Второе слагаемое в правой части (2) характеризует момент сил трения, эффективность к-рых определяется релаксат. параметром λ . Согласно ур-нию (2), длина вектора M постоянна, так что процесс сводится лишь к изменению его проекции M_z на направление $M_{эфф.}$. В общем случае Р. м. в магнитоупорядоченных телах протекает значительно сложнее. Под действием постоянного и переменных внеш. магн. полей в магн. системе может устанавливаться стационарное неравновесное состояние — магн. колебания или волны, диссипация к-рых определяется процессами Р. м. Причём вклады разл. механизмов зависят от параметров спиновой волны, магн. анизотропии, темп-ры и пр. Наиб. полно эти процессы изучены в ферромагн. дилектриках (см. *Ферриты*). Обычно самым быстрым процессом Р. м. при не очень низких темп-рах оказывается рассеяние элементарных спин-волновых возбуждений (*магнонов*) друг на друге за счёт обменного взаимодействия.

На этом этапе Р. м. устанавливается внутри квазиравновесие в системе магненов, однако M и M_2 сохраняют нач. значения. Характерное время этого этапа Р. м. имеет порядок $(kT_C/h)(T/T_C)^4$, где T_C — темп-ра Кюри (Кюри точка). Дальнейшая релаксация обусловлена слиянием и расщеплением магненов за счёт дипольного взаимодействия, а также их взаимодействием с фононами. При этом сначала устанавливается равновесное значение M , а затем происходит поворот намагниченности к направлению $H_{\text{эф}}$. Последний этап описывается ур-нием (2); типичные значения λ имеют порядок 10^6 с⁻¹.

На практике значит. вклад в диссипацию магн. колебаний вносят неоднородности кристалла: нарушение порядка в расположении магн. ионов в узлах решетки, разориентация осей лёгкого намагничивания, поры, трещины, шероховатость поверхности и т. д. Неоднородности приводят к дополнит. рассеению магненов — вклад этого механизма может на неск. порядков превосходить собственную спин-спиновую релаксацию. Значит. влияние на Р. м. оказывают также электроны проводимости в ферромагн. металлах, а также некоторые ионы с сильной спин-орбитальной связью (напр., трёхвалентные лантаниды), выступающие посредниками между СС и решёткой. В малых магн. полях в Р. м. вносят вклад процессы вязкого движения доменных стенок (см. Доменной стенки динамика).

Р. м. в ферримагнетиках и антиферромагнетиках обусловлена в общем теми же механизмами, что и в ферромагнетиках, однако эф. проявления осложнены наличием неск. магн. подрешёток. Особый случай представляют *спиновые стекла*, характеризующиеся широким спектром времён Р. м. и длительной релаксацией метастабильных магн. состояний.

Диамagnetики. Для них Р. м. обычно не выделяется в самостоят. объект исследования, поскольку подчиняется обычным законам взаимодействия электронов (связанных или свободных) с магн. полем. Ширина линии *циклотронного резонанса* в металлах и полупроводниках определяется длиной свободного пробега носителей заряда. Исключение составляют аномально сильные диамagnetики — сверхпроводники, где процессы Р. м. наиб. существенны в смешанном состоянии *сверхпроводников второго рода*.

Методы исследования магнитной релаксации. Наиб. широко используются резонансные методы: *электронный парамагнитный резонанс*, *ядерный магнитный резонанс*, ферро-, ферри-, антиферромагнитный резонансы. Поперечная релаксация обычно проявляется в возрастающих ширине ΔH резонансных линий до величин порядка $1/\tau_2$, а также в затухании сигналов спиновой прецессии и спинового эха. Спин-решёточная релаксация определяет величину стационарного поглощения энергии резонансного ВЧ-поля; кроме того, время τ_1 измеряется по восстановлению равновесной намагниченности после возбуждения мощным радиоимпульсом. Р. м. проявляется также в частотной зависимости динамич. магнитной восприимчивости — в частности, в релакс. поглощении энергии на частотах порядка $1/\tau_1$ и $1/\tau_2$. Применяются сочетания резонансных и нерезонансных методов, двойные резонансы, магнитоопт. эффекты и пр. Обширную информацию о Р. м. в магнитоупорядоченных веществах даёт набор, возбуждение *спиновых волн* с помощью ВЧ-накачки, изучение спиновых нестабильностей, параметрических ВЧ-аффектов и пр.

Изучение Р. м. предоставляет ценную информацию о природе магнетизма в разл. веществах, позволяя исследовать спин-спиновые, спин-фононовые и электронно-ядерные взаимодействия, атомно-молекулярную подвижность в конденсиров. средах. Р. м. играет существенную роль в работе устройств магн. памяти и магн. записи (см. *Память устройств*), во мн. случаях определяя их быстродействие и частотный диапазон; в методах получения сверхвысоких темп-р с помощью адиабатич. размагничивания (см. *Магнитное охлаждение*); в квантовых парамагн. усилителях (мазерах); в эффектах

динамики, поляризации ядер (см. *Ориентированные ядра*, *Овершарпера эффект*) и т. д.

Лит.: Абрагам А., Ядерный магнетизм, пер. с англ., М., 1963; Аллгшудер С. А., Коварев В. М., Зенитовский парамagnetизм, пер. с англ., М., 1970; Провини, неупорядоченные группы, 2 изд., М., 1972; Слиттер Ч., Основы теории магнитного резонанса, пер. с англ., 2 изд., М., 1981; Ахмедер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетминский В. В., Спиновые волны, М., 1987; Гуревич А. Т., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, М., 1978; Александров И. В., Теория магнитной релаксации. Релаксация в жидкостях и твёрдых немагнитических парамагнетиках, М., 1975; Абрагам А., Голядкин М., Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок, пер. с англ., т. 1—2, М., 1984.

В. А. Азаркин.

РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — заполняющее Вселенную практически изотропное ал.-магн. излучение с чернотельным спектром и темп-рой ок. 2,7 К (*фоновое космическое излучение*), интерпретируемое как реликт нач. стадий эф. эволюции. Подробнее см. *Микроволновое фоновое излучение*.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ (лоренц-инвариантность) — независимое физ. законов и явлений от скорости движения наблюдателя (или, точнее, от выбора *инерциальной системы отсчёта*). Р. н. законов фундам. физ. взаимодействия означает невозможность ввести выделенную систему отсчёта и измерить «абс. скорость» тел. Принцип Р. я. возник в нач. 20 в. в результате обобщения разл. опытных данных, начиная с отриц. результата эксперимента Майкельсона — Морли (1881—87) (см. *Макельсонова опыт*). Ныне наилучшие и наиб. многочисл. подтверждения Р. я. фундам. физ. взаимодействий дают опыты с элементарными частицами высоких энергий. Из принципа Р. я. вытекают существование нек-рой универсальной макс. скорости распространения всех физ. взаимодействий; эта скорость совпадает со скоростью света в вакууме. Математически Р. я. выражается в том, что ур-ния релятивистской механики Эйнштейна — Лоренца — Пуанкаре и электродинамики Максвелла (совокупность этих ур-ний образует спец. теорию относительности), а также теории сильного и слабого взаимодействий, не изменяют своего вида, если входящие в них пространственно-временные координаты в физ. полях подвергаются *Лоренца преобразованиям*. Для построения релятивистски инвариантной теории гравитат. взаимодействия понятие Р. я. должно быть обобщено (см. ниже).

Фундам. свойством Р. я. является то, что она имеет место для пространства и времени вместе (а не по отдельности), т. е. преобразования Лоренца перемещают пространственную и временную координаты. Это привело к введению понятия пространства-время — четырёхмерного псевдоевклидова многообразия, точками к-рого являются разл. события [А. Пуанкаре (H. Poincaré), Г. Минковский (G. Minkowski)]. Преобразования Лоренца можно интерпретировать как четырёхмерный гиперболич. поворот в этом многообразии.

В предельном случае относит. скоростей v , много меньших скорости света (когда пренебрегают всеми эффектами порядка v^2/c^2 и выше), Р. я. переходит в галилееву (нерелятивистскую) инвариантность — инвариантность относительно преобразования Галилея (см. *Галилеев принцип относительности*).

Р. я. специальной (частной) теории относительности, к-рая является гл. об. а. л. н. (в том смысле, что относит. скорость двух систем отсчёта и коэффициенты преобразования Лоренца постоянны во всём пространстве-времени), была обобщена в *общей теории относительности* Эйнштейна, где имеет место только л. к. а. л. я. Р. я. преобразования Лоренца относится к дифференциалам координат, а их параметры зависят от точки. Понятие Р. я. было также обобщено (с сохранением осн. свойств) на многомерные теории физ. взаимодействий, в т. ч. гравитат. взаимодействия (см. *Каулицы — Клейна теория*, *Суперструны*).

А. А. Старобинский.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА — раздел теоретич. физики, в к-ром рассматриваются ре-

лятивистские квантовые законы движения микрочастиц (электронов и др.) в т. н. одностепенном приближении. Релятивистские эффекты велики при энергиях частицы, сравнимых с её энергией покоя. При таких энергиях может происходить рождение частиц (реальных или виртуальных), поэтому рассмотрение одной частицы в общем случае неравномерно. Последоват. описание свойств релятивистских квантовых частиц возможно только в рамках *квантовой теории поля*. Однако в некоторых задачах образование частиц можно не учитывать и использовать волновые квантовые ур-ния, описывающие движение одной частицы (одностепенное приближение). Так находят, напр., релятивистские поправки к атомным уровням энергии (определяющие тонкую структуру). Такой подход является логически не замкнутым, поэтому Р. к. м., в к-рой рассматриваются задачи подобного типа, в отличие от релятивистской квантовой теории поля и нерелятивистской квантовой механики, не существует как последоват. теория. Основной расчёт в Р. к. м. служат релятивистские *Дирака уравнение* для электронов и др. частиц со спином $1/2$ и *Клейна-Гордона уравнение* для частиц со спином 0.

И. Ю. Кобzareв.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КОВАРИАНТНОСТЬ — см. *Ковариантность*.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МЕХАНИКА — раздел теорет. физики, рассматривающий классич. законы движения тел (частиц) при скоростях v , сравнимых со скоростью света c . Р. м. основана на частной (спец.) теории относительности. Осн. ур-ния Р. м. — релятивистское обобщение 2-го закона Ньютона и релятивистский закон сохранения энергии-импульса — удовлетворяют требованиям принципа относительности Эйнштейна. Из них, в частности, следует, что скорость материальных объектов не может превышать c . При $v \ll c$ Р. м. переходит в классич. механику Ньютона. См. *Относительности теория*.

И. Ю. Кобzareв.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ПЛАЗМА — плазма, в к-рой ср. энергия хотя бы движения частиц хотя бы одного сорта превышает энергию покоя этих частиц. Чаще всего релятивистской является электронная компонента плазмы. Р. п. обладает рядом особенностей, в частности частота её ленгмюровских колебаний зависит от темп-ры (ср. энергия) электронов, а шарные столкновения, вообще говоря, приводят к рождению новых частиц. Однако классификация колебаний и волн Р. п. качественно остаётся той же и для нерелятивистской плазмы (см. *Волны в плазме*).

В некоторых случаях релятивистские эффекты в плазме становятся существенными и при ср. энергиях электронов, существенно меньшей её энергии покоя (в 500 кВ). Так, релятивистские поправки к мощности тормозного излучения плазмы значительны уже при темп-ре электронов, соотв. их кинетич. энергии 50—70 кВ, а эффекты релятивистского замедления гирачоты электронов в случае электронного циклотронного резонанса — при ещё меньшей темп-ре.

В лаб. условиях плазму с релятивистскими электронами получают в магн. ловушках, чаще всего в пробирках (см. *Открытые ловушки*), воздействуя на первоначально холодную плазменную мишень мощным эл.-магн. излучением в диапазоне электронной циклотронной частоты. Др. способ получения Р. п. — более или менее длит. пропускание через плазму-мишень пучка заряж. частиц; возбуждаемые пучком плазменные колебания также могут приводить к ускорению значит. части электронов до релятивистских энергий (см. *Плазменная электроника*). Дальнейший рост энергий электронов может происходить за счёт адиабатич. сжатия такой плазмы, осуществляемого наращиванием магн. поля пробирочной (см. *Нагрев плазмы*). Р. п. встречается в астрофиз. объектах, напр. в магнитоферах пульсаров. Через состояние Р. п. проходила Вселенная в целом (см. *Горячей Вселенной теория*).

Д. Д. Рютков.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ СКОРОСТЬ — скорость v , близкая к скорости света c . Частица, движущаяся с Р. с., нав. р е л я т и в и с т к о й. Энергия свободной релятивистской частицы

$$E = mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

сравнима или больше удвоенной энергии покоя частицы: $E > 2mc^2$ (m_0 — масса покоя частицы); если $E \gg mc^2$, частица нав. ультрарелятивистской.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ — см. *Относительности теория*.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА — раздел термодинамики, изучающий преобразование термодинамич. величин при переходе от неподвижной системы к движущейся со скоростью, близкой к скорости света. Р. т. основывается на объединении идей специальной и общей теории относительности с классич. термодинамикой.

Осн. идеи Р. т. были разработаны М. Планком (M. Planck) и А. Эйнштейном (A. Einstein) в 1907 для случая спец. теории относительности. Обобщение Р. т. для случая общей относительности теории принадлежит в осн. Р. Толмэну (R. Tolman, 1928).

Термодинамич. величины, такие, как энергия E , импульс p , объём V и давление P , при переходе от покоящейся системы к системе, движущейся со скоростью v , преобразуются по релятивистским ф-лам:

$$E = (1 - \beta^2)^{-1/2} (E_0 + \beta^2 P_0 V_0);$$

$$p = (u/c^2) (1 - \beta^2)^{-1/2} (E_0 + P_0 V_0),$$
(1)

где $V = V_0 (1 - \beta^2)^{1/2}$, $P = P_0$, $\beta^2 = v^2/c^2$. Индекс «полю» означает, что величина рассматривается в собственной, неподвижной системе координат ($u = 0$); предполагается, что упругие напряжения создают лишь скалярным давлением P_0 , а скорость движущейся системы v постоянна.

Согласно первому началу классич. термодинамики, подведённая к системе теплота dQ и работа внеш. сил dA , произведённая над системой, связаны соотношениями

$$dQ = dE - dA,$$
(2)

$$dA = -P dV + u dp.$$
(3)

Из (1) и (2) следует, что

$$dQ = (1 - \beta^2)^{1/2} (dE_0 + P_0 dV_0).$$
(4)

Величина $E_0 + P_0 V_0 = Q_0$ есть *энтропия*, или тепловая ф-ция. Следовательно, закон преобразования кол-ва теплоты при переходе к движущейся системе:

$$dQ = (1 - \beta^2)^{1/2} dQ_0, \quad Q = Q_0 (1 - \beta^2)^{1/2}.$$
(5)

Собственно системе скорости v можно рассматривать как адиабатич. процесс, при этом *энтропия* S остаётся неизменной и в движущейся, и в неподвижной системах ($S = S_0$), т. е. инвариантна относительно Лоренца преобразований. Инвариантность энтропии следует из того, что она связана с равновесным распределением вероятности, когда переходы в неравновесное состояние невозможны.

Согласно второму началу термодинамики,

$$dQ = T dS.$$
(6)

Из сравнения (5) и (6) следует возможный закон преобразования темп-ры T при переходе от неподвижной системы к движущейся:

$$T = T_0 (1 - \beta^2)^{1/2}.$$
(7)

Однако такая зависимость не обязательна, что [как выяснил Г. Отт (H. Ott, 1967) [2]] связано с произволом

в определении кол-ва теплота. Передаваемую теплоту можно определить либо при пост. импульсе [как предположили Планк и Эйнштейн и что ведёт к ф-ле (7)], или при пост. скорости. Но т. к. в теории относительности импульс и скорость не пропорциональны, то второе определение δQ , связанное с передачей энергии при пост. импульсе, приводит к иному, чем (7), закону преобразования темп-ры в движущейся системе:

$$T = T_0 / (1 - \beta^2)^{1/2} \quad (8)$$

Это не вызывает к-л. затруднений и противоречий, т. к. термодинамич. процесс рассматривается в системе покоя (см. [2], с. 165).

Неравновесная Р. т. была разработана К. Эккартом [3] для однокомпонентной жидкости или газа и обобщена в 1953 для смеси Г. Клютенбергом, С. де Гроотом и П. Мауэром [4]. Здесь также теплота и её поток определяются неоднозначно, а имеются две возможности — Эккарта [3] и Ландау и Лифшица [5].

Второе начало термодинамики можно сначала представить в релятивистской форме в галилеевых координатах [2]:

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\varphi_0 \frac{dx^\alpha}{ds} \right) \delta x^\alpha \delta y^\alpha \delta z^\alpha \geq \frac{\delta Q_0}{T_0} \quad (9)$$

где знак «больше» относится к неравновесным процессам, φ_0 — собств. плотность энтропии в заданной точке в заданный момент времени, измеряемая локальным наблюдателем, покоящимся относительно жидкости или рабочего вещества, dx^α/ds — компоненты макроскопич. «скорости» жидкости в заданной точке в используемых координатах, δQ_0 — собств. теплота, измеряемая локальным наблюдателем, к-рая поступает в изучаемый элемент жидкости при собств. темп-ре T_0 за интервал времени наблюдения δt , входящий в ф-лу для четырёхмерного объёма $\delta x^\alpha \delta y^\alpha \delta z^\alpha$.

Для того чтобы получить формулировку второго закона термодинамики с учётом общей теории относительности, нужно привлечь принцип ковариантности и эквивалентности принципу (см. [2], гл. 9).

Р. т. позволяет исследовать условия термодинамич. равновесия с учётом хим. и ядерных реакций, а также гравитач. поля. Одна из областей применения Р. т. — космология, модели (см. Космология). Для разреженных газов Р. т. может быть разработана на основе релятивистской кинетич. теории и применена к системам лептонов, адронов, фотонов и электронов [6].

Лит.: 1) Паули В. Теория относительности, пер. с нем., 2 изд., М., 1983, гл. 3; 2) Толмен Р. Относительность, термодинамика и космология, пер. с англ., М., 1974; 3) Е с к а р т К., The thermodynamics of irreversible processes, 3. Relativistic theory of the simple fluids, «Phys. Rev.», 1940, v. 58, p. 918; 4) К л у т е н б е р г Г. А., de Groot S. R., Мауэр Р. Relativistic thermodynamics of irreversible processes, 1—2, «Physica», 1953, v. 19, p. 889, 1079; 5) Л а н д а у Л. Д., Л и ф ш и ц Л. Е. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988, гл. 15; 6) де Гроот С., ван Леуве В., ван Верт Х. Релятивистская кинетическая теория, пер. с англ., М., 1983. Д. Н. Зубарев.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ЧАСТИЦА — частица, кинетич. энергия к-рой ϵ сравнима с энергией покоя $m_0 c^2$ или больше её (m — масса частицы, c — скорость света). Скорость Р. ч. близка к скорости света. Если $\epsilon \gg m_0 c^2$, частица наз. ультрарелятивистской. Р. ч. получают в ускорителях заряженных частиц.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА — раздел высокочастотной электроники, посвящённый использованию релятивистских электронных пучков (РЭП) и (или) релятивистских эффектов для усиления, генерирования и преобразования эл.-магн. колебаний и волн. Релятивистские эффекты проявляются, как правило, при скоростях электронов v , соизмеримых со скоростью света c ($v \sim c$), когда энергия электронов

$$\epsilon = \frac{\epsilon_0}{\sqrt{1 - \beta^2/c^2}} = \epsilon_0 \gamma = \epsilon_0 + U$$

существенно отличается от их энергии покоя $\epsilon_0 = m_0 c^2 = 0,511$ МэВ, т. е. при $eU \gtrsim \epsilon_0$, где U — ус-

коряющий потенциал; однако роль этих эффектов может быть определяющей и в устройствах со слаборелятивистскими $v^2 \ll c^2$ электронными пучками (напр., в маэраэ на циклотронном резонансе — МЦР). Поскольку повышение ускоряющего потенциала является наиб. действенным способом увеличения мощности электронных пучков [макс. ток в вакуумном катде возрастает в нерелятивистском случае по закону степеней вторых: $I_{\text{макс}} = AU^{3/2}$, а в ультрарелятивистском ($\gamma \gg 1$) — пропорц. ускоряющему потенциалу $U_{\text{макс}} = BU$], то Р. э. представляет собой прежде всего область электроники больших мощностей. Вместе с тем ряд релятивистских эффектов позволяет получать когерентное эл.-магн. излучение с очень высокими частотами, недоступными для обычной релятивистской вакуумной электроники [см. Лазеры на свободных электронах (ЛСЭ)].

В Р. э. используются те же синхронизмы между электронами и эл.-магн. волнами (или, в общем случае, между спектральными компонентами ВЧ-полей), т. е. те же типы индукции, излучения электронов, что и в нерелятивистской классической электронике (табл.); однако особенности релятивистской кинематики в динамике релятивистского электрона приводят к радикальным различиям между законами, определяющими работу релятивистских и соответствующих нерелятивистских приборов, а также создают возможности реализации высокоэфф. приборов, не имеющих близких нерелятивистских аналогов. К числу важнейших эффектов, используемых Р. э., можно отнести следующие.

1. Поскольку при $\gamma \rightarrow \infty$ зависимость скорости электронов от их энергии становится всё более слабой:

$$\frac{dv}{d\epsilon} = \frac{v}{\epsilon} \cdot \frac{1}{\gamma^2}$$

то в системах с прямолинейными и слабоискривлёнными электронными пучками [напр., в генераторах, основанных на индуцированных Черенкова — Ваисюла излучении и переходном излучении, — лампе бегущей волны (ЛБВ), лампе обратной волны (ЛОВ), твистроне, оротроне] группировка пучка электронов, модулированного ВЧ-полем, происходит на всё больших пространственных масштабах. В результате оптич. длина пространства взаимодействия Л растёт пропорц. квадрату энергии электронов: $L/\lambda \sim \gamma^2$, а продольную составляющую элтрич. поля синхронной волны нужно

ВЧ-приборы с релятивистскими электронными пучками

Тип индуцированного излучения	Синхронизмы	Тип генератора (усилителя)
Черенкова — Ваисюла	$\omega = k_1 v$	ЛБВ ЛОВ Оротрон Магнетрон
Переходное	$\omega \approx k_1 v$	Клистрон Монокотрон Твистрон
Тормозное	$\omega = k_1 v + \omega_H$ $\omega = (k_1 + k_2) v$	Гиротрон МЦАР Убитрон (ЛСЭ)
Рассеяние волн (параметрическое)	$\omega - \omega' = (k_1 + k_2) v$	Сматтрон

Примечание: ω и k_1 — частота волны и продольное волновое число, ω_H — циклотронная частота, ω' и k_2 — частота волны и продольное волновое число накатки.

уменьшать, как γ^{-2} (тогда как в слабoreлятивистском случае обе эти величины пропорц. корню из величин энергии электронов). Такой закон подобия благоприятствует созданию мощных релятивистских электронных ВЧ-генераторов с высокоселективными пространственно-развитыми эл.-динами. системами.

2. При торможном излучении электронов с ростом их энергии максимум спектральной интенсивности смещается в область частот, существенно превосходящих частоты, представленные в неравномерном (напр., осцилляторном) движении частиц. Так, электрон, вращающийся с частотой Ω , излучает преим. на частотах $\omega \sim \gamma^2 \Omega$ (с эффектом Доплера), а электрон, совершающий малые колебания с частотой Ω и обладающий релятивистской поступат. скоростью $v \approx c$, излучает в направлении своего поступат. движения на частотах $\omega \sim \gamma^2 \Omega$ (релятивистский Доплера эффект). Аналогично этому при рассеянии волны на электроне, движущемся навстречу ей с релятивистской скоростью, частота рассеянного излучения в γ^2 раз превышает частоту падающей волны (релятивистский Комптона эффект). Указанные эффекты открывают возможность для продвижения соответствующих ВЧ-генераторов — убитрона, мазера на циклотронном авторезонансе (МЦАР), скаттрона — в особо коротковолновые диапазоны.

3. Поскольку поперечная масса электронов в γ^4 раз меньше продольной, то в отсутствие статич. поля, к-рое ограничивало бы их поперечное движение, группировка электронного пучка под действием ВЧ-модуляции развивается в поперечном направлении гораздо быстрее, чем в продольном. Этот эффект используется в секционир. приборах с поперечным отклонением электронов — гироскопе и оптич. кластроне.

4. В потоке электронов, вращающихся в однородном магн. поле H_0 , эл.-магн. волна вызывает иерцидную группировку двух типов: а) продольную (относительно H_0), обусловленную неоднородностью ВЧ-поля; б) орбитальную, обусловленную релятивистской зависимостью циклотронной частоты от энергии электронов. На этих эффектах основано действие МЦАР, среди к-рых с точки зрения получения больших мощностей в диапазоне миллиметровых и субмиллиметровых волн наиб. перспективны при слабо- и умеренно-релятивистских энергиях электронов *гиротроны* (как генераторы, так и усилители), при ультрарелятивистских — МЦАР.

Согласно теории, кнд электронных ВЧ-генераторов и усилителей сохраняется в принципе на уровне $\sim 10\%$ при любых, сколь угодно больших энергиях электронов.

Для практич. реализации мощных релятивистских электронных ВЧ-приборов необходимо прежде всего источники интенсивных РЭИ с достаточно малой дисперсией параметров, а также эл.-динами. системы с достаточными селективностью и электропрочностью. РЭИ, появившиеся еще в 1930-х гг. благодаря изобретению ускорителей, из-за ограниченности тока для генерации когерентного (коллективного) излучения были непродуктивны. Традиционная ВЧ-электроника освоила режимы с $U \approx 100$ кВ, при к-рых релятивистские эффекты начинают заметно влиять на динамику электронов, в 1950-х гг.; теперь импульсная мощность усилит. кластронов и гироскопов в диапазоне метровых и дециметровых волн достигает десятков МВт. С кон. 1950-х гг. в ВЧ-электронике начали использоваться и принципиально релятивистские эффекты. Первые генераторы такого рода были МЦАР (гиротроны); ныне непрерывная мощность гиротронов составляет величину ~ 300 кВт при $\lambda \sim 1$ см и превышает 1 кВт при $\lambda \sim 1$ мм, мощность в импульсах длительностью 10^{-4} — 10^{-1} с составляет величину ~ 100 кВт при $\lambda \sim 0,7$ мм и превышает 1 МВт при $\lambda \approx 3$ мм.

Возможность создания релятивистских электронных ВЧ-генераторов повнм. мощнои с импульсом длительностью 10^{-4} — 10^{-8} с возникла в кон. 1960-х гг. благодаря появлению сильноточных электронных ускорителей. Для генерации используются пучки электронов с энергиями 0,5—2 МэВ и токами 1—100 кА. Наиб. внимание уделяется на относительно длинных ($\lambda \approx 3$ мм) волнах генераторам, основанным на индукциях, черепковском излучении (релятивистским маэтроном, ЛОВ, оротрон и т. п.), а на относительно коротких ($\lambda \leq 3$ мм) волнах — генераторам, основанным на индукциях, торможном излучении и рассеянии волн (релятивистскому убитрону, МЦАР и т. п.). В этих генераторах применяются как вакуумные, так и твердотельные эл.-динами. системы. Достигаемая в настоящее время ВЧ-мощность при укорочении волн от 40 см до 0,5 мм можетно упадет до 40 ГВт до 1 МВт.

В кон. 1970-х гг. появились ВЧ-генераторы, позволяющие в качестве пикетров электронов использовать ускорители с повнм. ср. мощнои и тактовой частотой, позволяющей реализовать синхронизм между импульсами тока и эл.-магн. импульсом, последова-



Мощность генераторов когерентного электромагнитного излучения в зависимости от длины волны; ● — непрерывный режим, ■ — импульсный режим.

тельно отражающимся от зеркал открытого резонатора. Такие генераторы, представляющие собой разновидность убитронов, работающие при $\gamma \sim 10^4$, благодаря релятивистскому эффекту Доплера позволяют получать когерентное излучение в оптич. (лазерном) диапазоне и поэтому получили назв. лазеров на свободных электронах (рис.).

Приборы Р. э. находят применение в физ. эксперименте (неоднородное мощное излучение на вещество, в частности на плазму) и считаются перспективными для техн. (в частности, радиотехн.) приложений.

А. В. Рапопов-Грехов, М. И. Петелин.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА — раздел физики, посвященный изучению ядерных процессов, в к-рых частицы, составляющие ядро или материю, движутся со скоростями, близкими к скорости света с. Р. я. ф. сформировалась в 1970—72 в связи с экспериментами на пучках релятивистских ядер, полученных на синхротроне ОИЯИ (Дубна, СССР) и на бетатроне (Беркли, США). Как составляющая часть первичного космич. излучения релятивистские ядра наблюдались с 1948 в космич. лучах.

Введение. Традиц. модели ядра как системы нуклонов рассматриваются в рамках нерелятивистской квантовой механики и описываются эмпирич. факты, относящиеся к невязаным энергиям частиц — не более десятков и сотен МэВ (см. *Оболочечная модель ядра*). Релятивистские эффекты при таком подходе являются малыми поправками. В области относит. скоростей,

близких к скорости света c , теория ядерных процессов становится связанной с решением фундам. проблем теории квантовых полей. Для описания ядерных взаимодействий при скоростях ядерных частей, близких к c , понятие нуклона становится неадекватным, а протон-нейтронная модель — недостаточной. В качестве составляющих частиц ядерной материи (квантов) начинают выступать кварки и глюоны, динамика к-рых определяется ур-ниями квантовой хромодинамики (см. *Кварковые модели*).

Инвариантные переменные. Характерное явление Р. я. ф. — множественное рождение частиц (рис. 1).



Рис. 1. Множественное рождение адронов при столкновении релятивистского ядра ускорителя с ядром Та (пропаянная пузырьковая камера).

Пусть I и II — сталкивающиеся ядра (A_1, A_2 — массовые числа), а 1, 2, 3, ... — продукты реакции (A_1, A_2, A_3):

$$I + II \rightarrow 1 + 2 + 3 + \dots$$

Эксперим. методики позволяют определить импульсы всех частиц p_i, p_k , их массы m_i, m_k , энергии ϵ_i, ϵ_k (здесь индексы i, k обозначают и сталкивающиеся ядра и продукты реакции). Эти величины связаны соотношением

$$\epsilon_k^2 - p_k^2 = p_k^0^2 = m_k^2$$

(в системе $h = c = 1$), где p_k — четырёхмерный вектор импульса (см. *Скорость четырёхмерная*). Они служат основой для выбора кинематич. переменных, наиб. адекватно описывающих динамику закономерности процессов.

Физически значимой характеристикой пучков ядер является энергия, приходящаяся на 1 нуклон. Точно также энергию и импульс участвующих в реакции объектов надо делить на число составляющих их элементов (n о с т и т у е т в о в). Отношения импульсов адронов к их массам выступают в качестве характеристики ср. импульса, приходящегося на 1 конститuent. Вследствие этого процессы в Р. я. ф. описывают в терминах инвариантных положит. величин (безразмерных):

$$b_{ik} = -\left(\frac{p_i}{m_i} - \frac{p_k}{m_k}\right)^2 = -(u_i - u_k)^2, \quad (1)$$

где u_i, u_k — 4-векторы скоростей. Т. к. $p_i/m_i = p_k/m_k = 1$, то

$$b_{ik} = 2(u_i u_k - 1) = 2[(\epsilon_i \epsilon_k - p_i p_k)/m_i m_k - 1].$$

В системе покоя одной из частиц, напр. k , $b_{ik} = 2T_i/m_i$, где T_i — кинетич. энергия частицы i в системе покоя частицы k . Если частица k — ядро, то

$$b_{ik} = 2T_i/A_i m_0,$$

где $m_0 = 931$ МэВ (~ 1 ГэВ) — атомная единица массы (АЕМ). Для взаимодействия ядер i и k величина b_{ik} является кинетич. энергией одного из ядер, приходящейся на 1 нуклон и выраженной в АЕМ (практически — в ГэВ).

Распределения вероятностей W (сечения) процессов зависят только от b_{ik} и не зависят от энергии, передачи импульса и т. п. (при фиксированных b_{ik}). Это позво-

ляет воспользоваться методами подобия теории. Помимо соображений размерности и инвариантности в теории подобия используется гипотеза о том, что решения (в нашем случае — сечения) обладают асимптотич. поведением. Если разбить совокупность экспериментально определяемых величин на 2 группы $\{\dots b_{ik} \dots\}$ и $\{\dots b_{ik} \dots\} \beta$, то принцип самоподобия (автоматичности) приводит при достаточно больших α и β к соотношению

$$W(b_{\alpha k}, b_{\beta k}, b_{\alpha\beta}, \dots) = b_{\alpha\beta}^{-n} W^1(b_{\alpha k}, x_k). \quad (2)$$

Здесь индексы α, β могут относиться как к частицам, так и к образующимся комплексам частиц (кластерам), $x_k = b_{\beta k}/b_{\alpha\beta}$. Из (2) видно, что W^1 не зависит от $b_{\alpha\beta}$ (только от x_k) и обладает по этой переменной автоматичностью. Число n определяется из теории и измеряется в эксперименте. Из двух параметров подобия $b_{\alpha k}$ и x_k только x_k является масштабно инвариантным (см. *Масштабная инвариантность*).

Важным результатом обобщения эксперим. наблюдений является ослабление взаимодействия объектов α и β (ядер, адронов, кластеров в пространстве 4-скоростей) при увеличении их относит. скорости (при больших $b_{\alpha\beta}$). Это свойство может быть записано в виде

$$W^1 = W^{\alpha} W^{\beta} \rightarrow 0, \quad (3)$$

где W^{α}, W^{β} — вероятности процессов для подсистем α и β . Объединение свойств (2) и (3) даёт

$$W = b_{\alpha\beta}^{-n} W^{\alpha} W^{\beta}. \quad (4)$$

Распределения частиц в пространстве 4-скоростей распадаются на кластеры — группы точек u_i , расстояния между к-рыми $b_{ik} = -(u_i - u_k)^2$ значительно меньше ср. расстояния между всеми точками ансамбля. Изучение кластеризации в множественном образовании частиц позволило получить релятивистски инвариантное описание струй — резко направленных выбросов адронной материи при столкновении частиц и ядер. Согласно существующим представлениям струи являются продуктами превращения в адроны кварка или глюона, выбитого при столкновении исходных частиц. Изучение образования струй в столкновениях ядро — ядро важно для выяснения возможностей квантовой хромодинамики в описании микроструктуры атомных ядер. Исследование струй показало, что они в осн. состоят из n -мезонов. В системе покоя кластера α ($u_{\alpha} = 0$) кинетич. энергия шюва составляет 150 МэВ.

Классификация ядерных взаимодействий. Величины b_{ik} определяют области применимости моделей, описывающих механизмы взаимодействия частиц. Зависимость сечений взаимодействия от b_{ik} различна в разных интервалах их значений. Анализ множественных процессов при столкновении релятивистских ядер указывает на существование неск. характерных диапазонов значений b_{ik} . При $b_{ik} \sim 10^2$ можно рассматривать внутриядерное движение нуклонов, определяемое ср. кинетич. энергией движения нуклонов в ядрах. При $10^2 < b_{ik} < 1$ столкновения ядер можно рассматривать как столкновения квазисвободных нуклонов с распределением по импульсам внутр. движения, задаваемое обычной ядерной динамикой. При $b_{ik} \sim 1$ следует рассматривать движение связанных кварков. При $b_{ik} \gg 1$ можно говорить о столкновении квазисвободных кварков. Значение b_{ik} , начиная с к-рого реализуются режимы, обусловленные преобладанием кварковых степеней свободы, определяется условием

$$b_{ik} \gtrsim 5-8. \quad (5)$$

Это соответствует относит. скоростям частиц $v > 0,95$ с. Применение критерия (5) к столкновению ядер I и II даёт величину кинетич. энергии, необходимой

для изучения кварковых степеней свободы. Это означает, что при энергиях ядер $T > 3-4,7A$ ГэВ наступает асимптотич. режим, называемый предельной фрагментацией ядер. В этой области энергий спектры вторичных частиц (фрагментов ядер, пионов, каонов и т. д.) не зависят от энергии и сорта падающей частицы (ядра, адрона, фотона, лептона). Это соответствует общей закономерности (4) при $\alpha = 1, \beta = 11$.

В области предельной фрагментации ядер обнаружен ядерный кумулятивный эффект. Он состоит в рождении в неупругих ядро-ядерных (адрон-ядерных) столкновениях частиц, энергия к-рых превышает максимально возможную для взаимодействия с отд. нуклонами ядер. Кварковые степени свободы играют некую роль и в ядерных реакциях при $b_{ik} < 1$ и даже при $b_{ik} \sim 10^{-2}$ в свойствах осн. состояний ядер. Это связано с тем, что ср. расстояния между нуклонами в ядре сравнимы с радиусом пленения (конфайнмента) кварков. Существует вероятность туннелирования, перемешивания и даже обобществления кварков, принадлежащих отд. нуклонам. Эксперим. данные по ядерному кумулятивному эффекту свидетельствуют также о том, что в ядре наряду с нуклонами возникают «канальки кварк-мезонной плазмы» и что ядра могут рассматриваться как гетерофазные системы, представляющие собой смесь нуклонной и кварк-глюонной фаз.

Образование ядерных фрагментов. Реакция с релятивистскими ядрами в области $b_{11} > 1$, по при b_{11} (1-ядерный фрагмент) или b_{11} порядка 10^{-2} описываются протон-нейтронной моделью ядра. Учтё кварковые степени свободы в этой области даёт такие же малые поправки, как и для характеристик основных и низковозбуждённых состояний ядер. Сечение реакций столкновения ядер I и II с образованием ядерного фрагмента I расщепления ядра II имеет вид

$$\frac{d\sigma}{db_{11}} = \frac{F(b_{11})}{(b_{11} + \alpha_{11})^2} \quad (6)$$

при $b_{11} > 1, b_{11} \sim \alpha_{11} = 2\mathcal{E}_{11}(m_{11} - m_1)/m_{11}m_1 \approx 10^{-2}$. Здесь \mathcal{E}_{11} — энергия связи фрагмента I в ядре II, m_1 — масса фрагмента, F — слабо меняющаяся β -функция. Это соответствует ф-ле (4) при $\alpha = 1, \beta = 11$ и $\lambda = 2$.

Процессы с перераспределением нуклонов дают осн. вклад в полное сечение взаимодействия релятивистских ядер. На рис. 2 приведено распределение по продольному импульсу p^z ядер изотопов C, образующегося при столкновении релятивистских ядер ^{16}O с

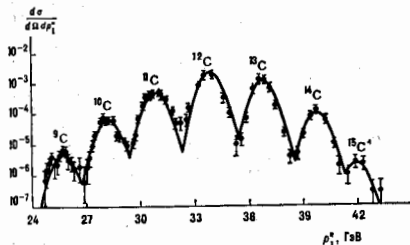


Рис. 2. Зависимость дифференциальных сечений образования изотопов углерода от их продольного импульса p^z в реакции $^{16}\text{O} + \text{He} \rightarrow \text{C}$ при их энергии ядер кислорода 2,1 ГэВ (единицы произвольные).

ядрами Be. Сечения процесса определяются ф-лой (6); условие $b_{11} = 0$ даёт положение максимумов, а величина α_{11} — их ширины. Малость α_{11} обуславливает большую величину полного сечения взаимодействия ядер. Зависимость сечения (6) от α_{11} определяет его

зависимость от A_{11} и A_1 , т. к. $m_{11} = A_{11}m_0, m_1 = A_1m_0$.

При достаточно больших величинах импульсов $|p_{11}|$ и $|p_1|$ величина b_{11} зависит только от отношения $|p_{11}|/|p_1|$, т. е. имеет место инвариантность по отношению к замене импульсов:

$$|p_{11}| \rightarrow \lambda |p_{11}|, |p_1| \rightarrow \lambda |p_1|,$$

где λ — константа. Эта зависимость отчётливо проявляется в образовании ядерных фрагментов, α -частиц, дейтронов, протонов (ядер λ с кей или λ).

Реакции перераспределения нуклонов между ядерными фрагментами при $b_{11} \sim 10^{-2}-10^{-1}$ важны для обнаружения и исследования короткоживущих радионуклидов, а также для получения пучков нестабильных барионных систем (напр., гиперядер). В области $0.1 \leq b_{11} \leq 1$ кварковые степени свободы играют существен. роль в перестройке взаимодействующих адронных систем. Т. к. сечения взаимодействия здесь относительно большие, то возможны исследования кварковых систем, отличающихся от обычных трёхкварковых (барионы) или кварк-антикварковых (мезоны), напр. дибарионных.

Предельная фрагментация ядер. Сечение рождения частицы 1 в области предельной фрагментации ядра II можно определить исходя из ф-лы (4) при $\alpha = 1, \beta = 2, n = 0$:

$$m_1^{-2} d^2\sigma/db_{11} dz_1 = F^1 F^{11} (b_{11}, z_1). \quad (7)$$

Здесь F^1 — множитель, слабо зависящий от b_{11} (т. е. от энергии столкновения), свойств ядра II и частицы 1; $z_1 = b_{11}/b_{11} = u_1^+ - u_1^-$, где $u_1^+ = \mathcal{E}_1/m_1, u_1^- = p_1^z/m_1$ (u_1^+ и p_1^z — проекция скорости и импульса на направление пучка). В случае $b_{11} \geq b_{11}$ обычно регистрируются вторичные частицы, вылетающие из мишени под углом больше 90° по отношению к направлению пучка адрон (нуклонов, мезонов, фотонов). Универсальность энергетич. и угл. зависимости образующихся частиц 1 (пионов, коонов) наблюдалась в широком интервале энергий столкновения, соответствующих $1 < b_{11} \leq 10^3$.

Представления о динамике образования частиц в области предельной фрагментации основаны на том, что в столкновениях ядер участвуют их малые части, несущие доли импульса, равные $(X_1/A_1)p_1, (X_{II}/A_{II})p_{11}$. Эти части (партоны) могут быть кварками и глюонами. Из законов сохранения энергии-импульса, записанных в виде

$$(X_1/A_1)p_1 + (X_{II}/A_{II})p_{11} = \sum_i p_i,$$

следует, что для предельной фрагментации ядра II при $b_{11} \gg 1$ необходимо условие

$$X_{II} > (m_1/m_0)z_1.$$

Здесь m_1 — масса мезона 1. Т. о., X_1 и X_{II} — мин. число нуклонов, допускаемое законами сохранения для образования частицы с заданной величиной z_1 . Кумулятивный эффект можно определять как реакцию образования частиц, описываемые ф-лой (7) (т. е. при $b_{11} \geq b_{11} \gg 1$) при $X_{II} > 1$. Величины $F^1(b_{11}, z_1) = (m_0/m_1)X_{II}$ являются фундам. характеристиками каждого ядра, т. к. система кумулятивная частица — ядро представляет собой, так же, как и кластеры, изомеров. систему. Для случая, когда поперечный импульс регистрируемой частицы $p_1^z = 0$:

$$F^1 \propto A_{II} \exp(-X_{II} \langle X_{II} \rangle), \quad (8)$$

$$\text{где } \langle X_{II} \rangle \approx 2/3 + (1/3)X_{II} \text{ при } 0.5 \leq X_{II} \leq 1, \text{ и } \langle X_{II} \rangle \approx 1 \text{ при } X_{II} > 1, A_{II} > 25.$$

Зависимость (8) при $X_{II} > 1$ универсальна для ядер от He до U (рис. 3, 4). Величина (X_{II}) = 0.14 и с точностью ~10% одинакова для всех ядер. Постоянство (X_{II}) для всех изученных ядер и всех b_{II} указывает на то, что эта величина является универсальным параметром ядерной материи.

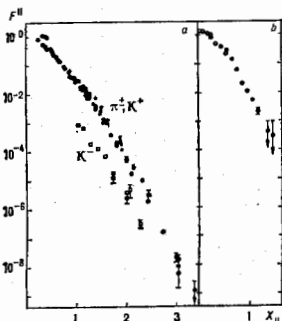


Рис. 3. Зависимость структурной функции ядер F^A от X_{II} , определённая из сечения кумулятивного образования π - и K-мезонов в протон-ядерных взаимодействиях.

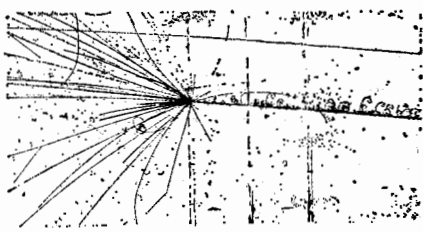


Рис. 4. Зависимость от массового числа A структурной функции ядер F^A в кумулятивной области ($X_{II} > 1$).

Экспериментальные методы требуют достаточно интенсивных пучков релятивистских ядер. Для ускорения ядер обычно используются модифицированные синхротронные протоны. Получение пучков ионов с максимальной возможной зарядом осуществляется либо предварит. ускорением малозарядных ионов, получаемых от обычных ионных источников с последующей полной «обдиркой» электронов на твёрдых и газообразных мишенях, либо путём использования спец. ионных источников, в к-рых образуются «голые» ядра (необходимо для устойчивого ускорения). Запуск в Дубне ускорителя «Иуколотрон» (1992) в сочетании с синхротроном даёт возможность ускорения ядер вплоть до U при высоких пространственно-временных характеристиках пучков.

Для изучения возбуждённых кластеров в пространстве 4-скоростей эффективны трековые детекторы частиц, позволяющие регистрировать множественное рождение частиц в условиях 4П-геометрии (пузырьковые камеры и др.).

Максимальная для данного ускорителя энергия ядер $T_{II}/A_{II} = m_0 b_{II}^2/2$ определяет возможность наблюдения

явлений, связанных с вывобождением цветных степеней свободы. При $b_{II} \geq 10$ образуются барьонные кластеры размером, определённым условием $\langle b_k \rangle \leq 0.1$. Ср. расстояние между кластерами порядка 1. При $b_{II} \geq 50$ формируются струи. Размер струи $\langle b_k \rangle \approx 4$. Струи разделяются, если расстояние между ними $b_{II} \sim 10$. При $b_{II} \geq 200$ происходит множественное образование струй. Область $b_{II} \geq 10^3$ будет достигнута после создания ядерных коллайдеров.

Лит.: В а л д и н А. М., Физика релятивистских ядер, «ЭЧАЯ», 1977, т. 8, № 3, с. 429; Ст а в и н с к и й В. С., Предельная фрагментация ядер — кумулятивный эффект (эксперимент), «ЭЧАЯ», 1979, т. 10, № 5, с. 949; Е ф р е м о в А. В., Quark-parton picture of the cumulative production, «Progr. Part. and Nucl. Phys.», 1981, т. 8, р. 385; Г л а н к и н Г. Л., S t r i k m a n M. I., High energy Phenomena Short-Range nuclear structure and QCD, «Phys. Repts», 1981, v. C76, p. 216; В а л д и н А. М., Study of the nuclei A8 quark-gluon systems in relativistic nucleus collisions, «Nucl. Phys.», 1980, v. A47, p. 203; В а л д и н А. М., Д и д е н к о Л. А., Asymptotic properties of Hadron Matter in relative 4-velocity space, «Fortachr. Phys.», 1990, v. 38, № 4, p. 261. А. М. Балдин.

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЭФФЕКТЫ — физ. явления, наблюдаемые при скоростях тел (частиц) v , сравнимых со скоростью света c . К ним относятся: релятивистское сокращение продольных (в направлении движения тела) длин, релятивистские замедление времени, увеличение массы тела с ростом его энергии и т. п., рассматриваемые в частной (специальной) относительности теории. Для квантовых систем частиц (атомов, атомных ядер и др.), в к-рых относят. движение частиц происходит со скоростями $v \ll c$, Р. э. даёт поправки к уровням энергии, пропущ. степеням отношения v/c (см., напр., Спин-орбитальная взаимодействие). Релятивистскими наз. также эффекты общей теории относительности (релятивистской теории тяготения), напр. эффект замедления течения времени в сильном гравит. поле (см. Тяготение).

И. Ю. Кобзарев.
РЕНИЙ (Rhenium), Re, — хим. элемент побочной подгруппы VII группы периодич. системы элементов, ат. номер 75, ат. масса 186,207. Природный Р. состоит из двух изотопов: стабильного ^{187}Re (37,40%) и слабо β -радиоактивного ^{187}Re (62,60%, $T_{1/2} = 4,3 \cdot 10^{10}$ лет). Электронная конфигурация внеш. электронных оболочек $5s^2 4d^6 5p^6$. Энергия последоват. ионизации 7,87 и 16,6 вэ соответственно. Атомный радиус 0,137 нм, радиус иона Re^{4+} 0,052 нм. Значение электроотрицательности 1,46.

В свободном виде Р. — пластичный серебристо-серый металл с гексагональной плотнупакованной решёткой, её постоянные $a = 0,2757$ и $c = 0,4463$ нм. Плотность 21,03 г/см³, $t_{пл} = 3190^\circ\text{C}$, $t_{кип}$ ок. 5600°C . Уд. теплоёмкость $c_p = 25,2$ Дж/моль·К, теплота плавления 33 кДж/моль, теплота сублимации 744 кДж/моль. Темп-ра Дебая 415 К, темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 1,7 К. Уд. электр. сопротивление 0,172 мкОм·м, термич. коэф. электр. сопротивления $3,5 \cdot 10^{-4}$ К⁻¹ (при 0—100°С). Парамагнетик, магн. восприимчивость $\chi = 0,373 \cdot 10^{-4}$. Теплопроводность 59—71 Вт/(м·К). Термич. коэф. линейного расширения $6,0 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹ (при 20—500°С). Твёрдость по Бринеллю 1,3—1,5 ГПа, модуль упругости 467 ГПа. Высокопластичен, при 194°С монокристалл выдерживает изгиб на 90°.

По хим. свойствам аналогичен W. В соединениях проявляет степен окисления от -1 до +7.

Р. применяют как эмиттер электронов (рениевые острия в автокатадах, катоды в масс-спектрографах и т. д.), в электронной аппаратуре (подогреватели катодов и т. п.). Р. и его сплавы с W и Mo используют для изготовления термометр. В качестве радиоактивного индикатора служат ^{187}Re (электронный захват, β -распад, $T_{1/2} = 90,6$ ч) и др. радионуклиды Р.

С. С. Вердоско.

РЕПОРМАЛИЗАЦИОННАЯ ГРУППА (реворми-группа) в теоретической физике — однопараметрич. группа преобразований, состоящих в из-

менения масштаба (или операции сдвига) одной из физ. величин (аргумента) и в одноврем. изменения функции, зависимости от неё др. физ. величин. Р. г. возникает, когда матем. описание физ. задачи включает выбор частного решения, удовлетворяющего граничному условию при некотором значении аргумента (в нек-рой точке нормировки), а эквивалентность относительно преобразований Р. г. отражает независимость физ. содержания от выбора точки нормировки.

Р. г. была впервые обнаружена в *квантовой теории поля* (КТП) Э. Штокельбергом (E. Stueckelberg) и А. Петерманом (A. Peterman) в 1953, где она может быть сформулирована как группа преобразований осн. характеристик (вершинных ф-ций, одетых пропагаторов, перенормированных констант взаимодействий) и одновременно параметра, фиксирующего масштаб шкалы импульсных переменных (см. вкнже). В 1955 Н. Н. Боголюбов и Д. В. Ширков предложили регулярный метод улучшения результатов квантовополевой теории возмущений — метод Р. г., к-рый был им эффективно применён к исследованию УФ- и ИК-особенностей в *квантовой электродинамике* (КЭД).

Наиб. важная область применения метода Р. г. в КТП связана с анализом УФ-асимптотик, т. е. с поведением решений в малых λ (микроскопич. смысле) расстояниях. С помощью метода Р. г. в нач. 1970-х гг. обнаружено свойство *асимптотической свободы* неабелевых калибровочных теорий, явившееся теоретич. основой объяснения партоновой модели строения адронов (см. *Партон*) и привел к формулировке совр. теории сильного взаимодействия — *квантовой хромодинамики*.

Примерно в это же время метод Р. г. был перенесён К. Вильсоном (K. Wilson) из КТП в теорию *критических явлений* и использован для вычисления характеристик *фазовых переходов*. Впоследствии этот метод был плодотворно использован в др. разделах теоретич. физики: теории турбулентности, физике полимеров, теории переноса, магн. гидродинамике и нек-рых других, содержащих статистич. описание физ. явлений. Основой для применения методов Р. г. в отд. случаях служит теорема эквивалентности задачи вычисления *корреляционных функций* данной статистич. модели и задачи вычисления *Грина функций* нек-рой квантовополевой модели. Первоначально такая эквивалентность была установлена для статистич. моделей равновесной термодинамики, а затем этот результат был распространён на ряд задач стохастич. динамики.

Общий взгляд на природу преобразований Р. г. в различных, далёких друг от друга областях может быть сформулирован с помощью понятия *функции аналогичного подобия*, обобщающего известное в гидродинамике представление о степенном подобии, или *автоподобности*. Простейшее преобразование функций, автоматическими затрагивает две физ. величины x и g и имеет вид

$$R(t) = \{x \rightarrow x' = xt, g \rightarrow g' = \bar{g}(t, g)\},$$

где t — непрерывный параметр преобразования, изменяющий шкалу переменной x , а g — ф-ция, удовлетворяющая функциональному ур-нию

$$\bar{g}(t, \tau) = \bar{g}(t, \bar{g}(\tau, g)), \quad (1)$$

в силу к-рого преобразования $R(t)$ обладают групповым свойством $R(t)R(\tau) = R(t\tau)$ и образуют непрерывную группу (Ли группу). В частном случае, когда \bar{g} линейна по второму аргументу, решение ур-ния (1) имеет вид $\bar{g}(t, g) = gt^k$, где k — произвольное число, и преобразование $R(t)$ принимает вид преобразования степенного подобия. Поэтому в общем случае преобразование $R(t)$ оказывается функциональным обобщением последнего.

Использование Р. г. в разных областях физики в каждом случае опирается на пару величин типа x и g , для к-рых могут быть сформулированы преобразования функционального подобия. Так, в КЭД (ниже для простоты в безмасшобном случае, или, что эквивалентно, в УФ-пределе) такую пару образуют квадрат 4-импульса фотона k^2 и значение элетрич. заряда электрона $e(\mu^2)$, измеренное виртуальным фотоном с $k^2 = \mu^2$, т. е. в точке нормировки μ^2 (в статье принята система единиц, в к-рой $\hbar = c = 1$). Ренормгрупповое преобразование безмасшобной КЭД может быть записано в виде

$$R(t) = \{\mu^2 \rightarrow \mu^2 t, \alpha \rightarrow \bar{\alpha}(t, \alpha)\},$$

где вместо заряда e использована величина $\alpha = e^2/4\pi$, являющаяся параметром разложения теории возмущений. Ф-ция $\bar{\alpha}$, пропорциональная квадрату *эффективного заряда* электрона, удовлетворяет функциональному ур-нию (1).

Поскольку группа Ли может быть полностью охарактеризована своим бесконечно малым элементом, место функциональных ур-ний можно рассматривать дифференциальные, отвечающие преобразованиям $R(t)$ при t , близких к единице. Такое ур-ние для $\bar{\alpha}$ может быть записано в виде

$$t \frac{\partial \bar{\alpha}(t, \alpha)}{\partial t} = \beta(\bar{\alpha}(t, \alpha)), \quad (2)$$

где ф-ция $\beta(\alpha)$, представляющая собой *генератор группы*, определена соотношением

$$\beta(\alpha) = \left. \frac{\partial \bar{\alpha}(t, \alpha)}{\partial t} \right|_{t=1}. \quad (3)$$

Метод Р. г. о к-ром говорилось выше, состоит в том, что β -функция определяется по ф-ле (3), в правой части к-рой используют для $\bar{\alpha}$ приближённое выражение из теории возмущений.

Напр., в КЭД, исходя из результатов однопетлевой теории возмущений (ТВ) в УФ-области для эфф. константы сильного взаимодействия

$$\bar{\alpha}_s^{TB}(t, \alpha_s) = \alpha_s - b_1 \alpha_s^2 \ln t + O\left(\frac{\alpha_s^3}{t}\right), \quad b_1 > 0,$$

по ф-ле (3) получают $\beta(\alpha_s) = -b_1 \alpha_s^2$. Используя это выражение в (2) и интегрируя полученное нелинейное дифференц. ур-ние, находят

$$\bar{\alpha}_s^{pr}(t, \alpha_s) = \alpha_s(t^{-1} + b_1 \alpha_s \ln t). \quad (4)$$

Это выражение является точным решением дифференц. ур-ния (2) (и группового функционального ур-ния (1)). В то же время при разложении в ряд по α_s оно даёт соответствие с использованным приближённым выражением $\bar{\alpha}_s^{TB}$. Поэтому можно сказать, что метод Р. г. даёт синтез теории возмущений и ренормгрупповой инвариантности. Полученное выражение (4) содержит сумму всех «главных» логарифмич. вкладов вида $\alpha_s^n \ln^n t$ и может быть использовано вплоть до бесконечно больших значений t . Как можно показать, параметр t здесь следует отождествить с отношением k^2/μ^2 , где k^2 — квадрат 4-импульса, а μ^2 — точка нормировки (т. е. его значение, использованное для определения численного значения константы α_s), $\alpha_s \equiv \bar{\alpha}_s(k^2 = \mu^2)$. Поэтому предел $t \rightarrow \infty$ отвечает УФ-асимптотике $k^2 \rightarrow \infty$. Из ф-лы (4) теперь видно, что в этом пределе $\bar{\alpha}_s \rightarrow 0$, что и соответствует асимптотической свободе.

Учёт высших членов теории возмущений при определении генератора $\beta(\alpha)$ в принципе позволяет систематически улучшать ф-лу вида (4). Так, в КЭД ос. рабочей ф-лой для эфф. заряда $\bar{\alpha}_s$ является ренормгрупповая ф-ла 2-петлевого приближения, к-рая варьду с

«главным» вкладом суммирует также вклады вида $\alpha^2 \langle \alpha_{ij} \rangle_{ij}$ и в области больших l содержит зависимость от $l^2 n_{ij}$, не возникающего в самой теории возмущений.

Ренормгрупповые ф-лы вида (4) для эфф. констант связи *электрослабого взаимодействия* и сильного взаимодействия явились исходным материалом при формулировке гипотезы *великого объединения* взаимодействий. Матем. аппарат великого объединения основан на системе связанных дифференц. ур-ний для векс. эфф. констант связи, являющейся обобщением ур-ния (3).

В теории критич. явлений пару (z, g) образуют размер эфф. вектора спинового блока и константа спиновой связи соседних блоков, в теории полимеров — размер эфф. вектора элементарного звена полимерной цепи и сила взаимодействия между соседними звеньями и т. д.

Метод Р. г., предложенный более 30 лет назад для анализа УФ-поведения, всё чаще ныне используется в разл. областях физики.

Лит.: С. И. Стеклова Е. А. Петерманн А. A. La postolization of the coupling constants in the theory of renormalization group, *Phys. Acta*, 1953, v. 26, p. 499; Gell-Mann M., Low F., *Quantum electrodynamics at small*, «Phys. Rev.», 1954, v. 95, p. 1300; В о р о б о в Н. Н., Ш и р к о в Д. В., Приложение ренормализационной группы к тулельно формул теории возмущений, «ДАН СССР», 1955, т. 103, № 3, с. 391; и х же, Введение в теорию квантованных полей, 4 изд., М., 1984, гл. 9; В и ль с о н К., К о г у т Д. ж., Ренормализационная группа и ервлоложение, пер. с англ., М., 1975; В е Д о м б р и с л а С., M a r t i n P. C., Energy spectra of certain randomly-attributed fluids, «Phys. Rev. A», 1979, v. 19, № 1, p. 419; А д ж е м я н Л. П., В а с и л ь е в А. Н., Л и с к а м Ю. М., Ренормгрупповый подход в теории турбулентности, «ТМФ», 1983, т. 37, № 2, с. 288; Ш и р к о в Д. В., Ренормгруппа и фунд. яльная абсолютность в различных областях физики, «ТМФ», 1984, т. 40, с. 218; В е д о к у р о в В. В., Ш и р к о в Д. В., Теория взаимодействия частиц, М., 1980, § 12; Ш и р к о в Д. В., Новый метод теоретической физики, в сб.: Наука и человечество, 1987, М., 1987.

РЕНОРМАЛИЗАЦИОННАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ — требование самосогласованности процедуры перенормировки, состоящее в том, что наблюдаемые физ. величины, вычисленные с помощью первоначальных и изменённых — ренормированных — параметров теории (масс, констант взаимодействия), должны совпадать. Ренормированные параметры можно вводить попарно (см. *Перенормировки*); переходы от одного способа введения параметров к другому составляют *ренормализационную группу*.

С. В. Ефремов.

РЕНОРМИГРУППА — см. *Ренормализационная группа*.

РЕНОРМИРОВКА — см. *Перенормировки*.

РЕНТЕН (P, R) — внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атм. воздух. Назв. в честь В. К. Рентгена (W. K. Röntgen). При облучении 1 см³ воздуха дозой в 1 P образуются такие кол-во положит. и отрицат. ионов, что суммарный заряд каждого атома равен единице заряда СГС. 1 P = 2,57976·10⁻⁴ Кл/кг.

РЕНТЕНА ОПЫТ — один из классич. экспериментов по *электродинамике движущихся сред*, доказавший, что при связанных зарядах (ток Рентгена), возникающий при движении наэлектризов. диэлектрика, по своему магн. действию тождествен с током проводимости и с конвекц. током свободных зарядов (током Роуланда; см. *Роуланд опит*). Осуществлен в 1888 В. К. Рентгеном (W. K. Röntgen).

Плотность тока Рентгена ($\rho_{\text{Рентг}}$), обусловленного перемещением связанных зарядов плотностью $\rho_{\text{св}}$ с малой скоростью u ($u \ll c$), равна

$$j_{\text{св}} = \rho_{\text{св}} u, \quad \rho_{\text{св}} = -\operatorname{div} P, \quad P = \frac{e-1}{4\pi} E, \quad (1)$$

где P — поляризация диэлектрика во внеш. электрич. поле E , e — диэлектрич. проницаемость. Наличие тока связанных зарядов означает, что в движущемся поляризов. диэлектрике появляется магнитичность с плотностью магн. момента M , равной

$$M = [P \times c]. \quad (2)$$

Это видно из того, что $j_{\text{св}} = \operatorname{rot} \operatorname{div} P = \operatorname{rot}[P] = = \operatorname{rot} M$, где предпоследнее равенство справедливо при пост. скорости u . Соотношение (2) автоматически получается из материальных ур-ний Минковского (см. *Оптика движущихся сред*), к-рые для медленно движущихся немагнитич. (магн. проницаемость $\mu = 1$) сред можно записать в виде

$$P = (D - E)/4\pi = ((e-1)/4\pi)(E + [(u \times c)E]), \\ M = (B - H)/4\pi = ((e-1)/4\pi)[(u \times c)E], \quad (3)$$

или $P = [Mu \times c]$, $M = [P \times c]$, где E и H — напряжённости электр. и магн. полей, D и B — электр. и магн. индукция.

Схема Р. о., в к-ром был обнаружен ток связанных зарядов (1), такова. Круглый диэлектрич. диск (эбонитовый или стеклянный) вращается вокруг своей оси между обкладками плоского дискообразного соосного конденсатора. Если конденсатор заряжен, то на нём появляется электр. поле, поляризующее диэлектрич. На поверхностях диска, обращённых к обкладкам конденсатора, появляются связанные заряды с поверхностной плотностью $\sigma_{\text{св}} = ((e-1)/4\pi)E$. При вращении диска вокруг его оси эти связанные заряды создают ток, появление к-рого обнаруживается по отклонению чувствительной магн. стрелки, помещённой вблизи прора. При изменении знака напряжения на обкладках конденсатора (при этом не меняется знак связанного заряда) или при изменении направления вращения диска ток связанных зарядов, а следовательно, и отклонение магн. стрелки меняются на обратные. Ввиду малости величины этого тока, пропорционального величине u/c , точные количеств. измерения Рентген осуществлять не смог. Впоследствии их выполнил А. Эйнвальд (см. *Эйнвальда опит*).

Кроме тока связанных зарядов (1), Рентген обнаружил также ток поляризации:

$$j_{\text{поляр}} = \partial P / \partial t. \quad (4)$$

Чтобы исключить влияние на магн. стрелку тока связанных зарядов, диэлектрич. диск приводился во вращение между обкладками двух ридом расположенных конденсаторов, в к-рых электр. поле было одинаковым по величине, но противоположным по направлению. В момент прохождения диэлектрика через щель между конденсаторами его поляризация изменялась от $+P$ до $-P$, что приводило к изменению тока поляризации (4). Точные количеств. измерения этого тока были также выполнены в опятах Эйнвальда.

Лит.: Т а м и И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Б е к к е р Р., Электронная теория, Л. — М., 1941; Ф р а н к ф у р т У. И., Сверхтонкая и общая теория относительности, М., 1968; Б о л о т о в с к и й В. М., С т о л д я р о в С. И., Поля излучения и индукция в движущей среде, в кн.: Институтский сб. 1976—1979, М., 1983; М е р в о в и ч Э. А., М е с е р о в и ч В. Э., Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике, М., 1987.

РЕНТГЕНОВСКАЯ АСТРОНОМИЯ — раздел экспериментальной (наблюдательной) астрономии, исследующий источники космич. рентг. излучения. Рентг. диапазон определяется интервалом длин волн от 100 Å до 0,1 Å (энергия фотонов, ϵ , — от 100 эВ до 100 кэВ). Наблюдения космич. рентг. источников возможны в этом диапазоне вследствие достаточно высокой прозрачности межзвёздной среды для фотонов с $\epsilon > 10^2$ эВ. В мягком рентг. диапазоне ($\epsilon = 0,1$ —30 кэВ) межзвёздная среда с концентрацией атомов 0,1—1 см⁻³ прозрачна вплоть до расстояний 10—100 пк, в жёстком ($\epsilon = 30$ —100 кэВ) — до 10 кпк и более, что даёт возможность наблюдать рентг. излучение на относительно высоких галактич. широтах ($b \geq 10^\circ$) во всём объёме *Галактики*, а также исследовать внегалактич. источники. Земная атмосфера полностью непрозрачна для космич. рентг. излучения вследствие его поглощения на высотах от 120 до 40 км. Жёсткое рентг. излучение может исследоваться при помощи баллонов с высот

30—45 км, мягкое — лишь с ракет и ИСЗ с высот св. 100—150 км.

Рентг. излучение Солнца исследуется с 1947 с помощью ракет, хотя его наличие предполагалось и ранее (на основе изучения ионосферы Земли во время солнечных затмений). Рентг. источники несолнечной природы были случайно обнаружены в 1962 группой амер. исследователей под руководством Б. Росси (В. Rossi) и Р. Джакони (R. Giacconi) при поисках флуоресцентного рентг. излучения Луны, вызванного бомбардировкой ее поверхности космич. лучами. Наблюдавшиеся рентг. светимости источников ($10^{27} - 10^{28}$ эрг/с) существовали (на 3—5 порядков) превышали интегральные светимости нормальных звезд.

Механизмы генерации космич. рентг. излучения. К осн. механизмам эфф. генерации космич. рентг. излучения относятся следующие:

- тормозной механизм, связанный с пролетом свободных электронов вблизи атомных ядер (см. *Тормозное излучение*). Этот механизм эффективен для УФ- и рентг. излучения вплоть до энергии фотонов ~ 100 кэВ. Он же является ответственным и за потеря энергии электронами в горячей плазме. Для большой оптич. толщины ($\tau > 1$) в равновесной плазме спектр излучения — планковский, его максимум достигает рентг. диапазона при $T \geq 10^6$ К. Для $\tau < 1$ интенсивность не зависит от длины волны (плоский спектр);

- синхротронный механизм, связанный с движением электронов высоких энергий в магн. поле (см. *Синхротронное излучение*). Для космич. объектов с магн. полем $\sim 10^{-8}$ эв. рентг. излучение начинает испускаться электронами с энергией $\geq 10^{13}$ эВ. Как правило, при этом генерируется степенной спектр излучения;

- комптоновский механизм, связанный с рассеянием фотонов низких энергий (видимого, ИК- и радиодиапазонов) на релятивистских электронах (см. *Комптона эффект*);

- механизм, обусловленный связанно-связанными переходами внутренних электронов тяжелых понов (линейчатое излучение);

- циклотронный механизм, связанный с движением свободных электронов в сильном магн. поле (см. *Циклотронное излучение*).

Методы регистрации космич. рентг. излучения. Для регистрации космич. рентг. излучения используются детекторы веск. типов, принцип действия к-рых основан на разл. механизмах поглощения рентг. фотонов веществом.

В области $\mathcal{E}_\gamma = 0,1 - 40$ кэВ в Р. а. наиб. эффективно применяются газонаполненные пропорциональные счётчики, площадь к-рых может достигать 1 м^2 . Окнами в таких детекторах являются бериллиевая или алюминиевая фольга толщиной 10—100 мкм либо органич. тонкие (0,5—20 мкм) плёнки (лавсан, полипропилен и др.). В счётчиках с окнами из тонких плёнок приходится непрерывно возобновлять вытекающий газ (газороточные счётчики). В качестве наполнителя в детекторах этого типа служат тяжёлые инертные газы (Ar, Xe) с небольшими добавками (3—5%) электроотрицат. газов (CO_2 , CH_4 и др.), обеспечивающих самозащитную разряд после фотоионизации энергичным фотоном. При коэф. усиления $\sim 10^3 - 10^4$ такие счётчики обеспечивают пропорциональность амплитуды элечрич. импульса (связанное с анода счётчика) энергии регистрируемого фотона. При 30—40 фотоэлектронах на регистрируемый фотон (с $\mathcal{E}_\gamma \approx 5$ кэВ) энергетич. разрешение $\Delta \mathcal{E} / \mathcal{E}_\gamma \sim \mathcal{E}_\gamma^{-1/2}$ такого детектора не превышает 15—20%.

В области $\mathcal{E}_\gamma = 30 - 400$ кэВ обычно используются сцинтилляц. детекторы с кристаллами NaI или CsI, активированные добавками К, либо сцинтиллирующие пластинки площадью до 300 см^2 и более. Энергетич. разрешение этих детекторов также невелико ($\approx 20\%$ при $\mathcal{E}_\gamma \approx 50$ кэВ). Импульсы видимого излучения, возни-

кающие в кристаллах, регистрируются фотоэлектронными умножителями.

В области $\mathcal{E}_\gamma \leq 1$ кэВ применяются канальные фотоумножители, микроканальные пластинки или полупроводниковые детекторы. Детекторы этого типа имеют небольшие размеры (1—3 см) и для эфф. регистрации малых потоков рентг. излучения нуждаются в собирающих (концентрирующих) зеркалах. Зеркала косога падения (с углами падения, превышающими 88°), изготовленные из металлов с большими атомными номерами (Au, Pt), обладают достаточно высоким коэф. отражения (от 0,1 до 0,8). Комбинация двух зеркал (напр., парабола и гипербола вращения) обеспечивает разрешение до $1 - 2''$ при входной апертуре телескопа 10—70 см (рис. 1). В рентг. телескопах такого типа ис-

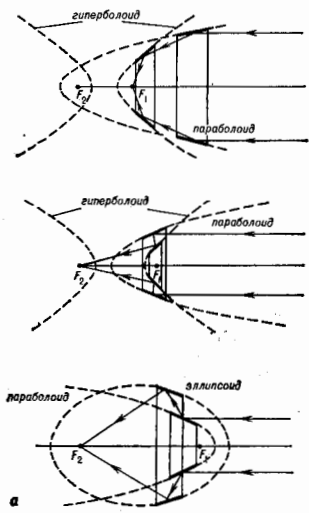


Рис. 1. Схема отражательного двухзеркального рентгеновского телескопа косога падения. Для увеличения рабочей площади исконно таких телескопов могут быть введены один в другой.

пользуются координатные детекторы, позволяющие получать изображения рентг. источников с разрешением, близким к разрешению оптич. телескопов.

Разрешение не лучше $1''$ дают механич. сеточные коллиматоры с размерами ячеек до 1 мм. Существенно лучшее разрешение (до $20''$) достигается с помощью модуляц. коллиматоров, состоящих из двух и более рядов параллельных нитей диаметром d , расположенных на расстоянии $L \gg d$. Диаграмма направленности таких коллиматоров состоит из мн. треугольников с уменьшающейся по мере удаления от центр. максимума пропусканием (рис. 2).

В мягком рентг. диапазоне спектральное разрешение ($R = \lambda / \Delta \lambda$) $\sim 10^3 - 10^4$ достигается с помощью брагговских кристаллич. отражат. спектрометров.

Первым ИСЗ, специально предназначенным для исследования космич. рентг. излучения, был спутник «Ухуру» (США, 1970). Наиб. успешные эксперименты проведены на спутниках «САС-3», «ХЕАО-1», «ХЕАО-2» (США), «АНС» (Нидерланды), «УК-5» (Великобритания), «Акухутэ», «Темпа» и «Гинга» (Япония), «Астрон» (СССР), «Экзосат» и «Росат» (Европейское

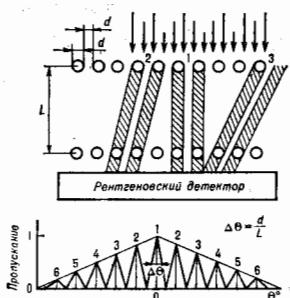


Рис. 2. Схема модуляционного рентгеновского коллиматора для определения координат и угловых размеров источников.

космич. агентство). В Р. а. за единицу потока рентг. излучения принята 1 единица «Ухуру», равная $1,14 \cdot 10^{-9}$ фотонов $\text{см}^{-2} \text{с}^{-1}$, или $1,7 \cdot 10^{-11}$ эрг $\text{см}^{-2} \text{с}^{-1}$ в диапазоне $\mathcal{E}_r = 2-20$ кэВ. Так, напр., рентг. телескоп спутника «Астрон» за 1 ч наблюдения мог регистрировать источники с потоком ~ 1 единицы «Ухуру» (в области $\mathcal{E}_r = 2-25$ кэВ), а телескоп ИСЗ «ХЕАО-2» за время экспозиции порядка суток имел предельную чувствительность $\sim 10^{-5}$ единиц «Ухуру» ($\mathcal{E}_r = 0,1-2$ кэВ).

Объекты и результаты исследований. Рентг. светимость Солнца не превышает 10^{31} эрг с^{-1} ($10^{-6}-10^{-7}$ полной светимости). Источником рентг. излучения Солнца является его корона с темп-рой $\approx (1-2) \cdot 10^6 \text{К}$. На непрерывный спектр накладываются линии высокоионизованных тяжёлых ионов Fe, Ni, Co и др. (см. Солнце).

Известные рентг. источники, число к-рых превышает 10^3 , чётко делятся на галактич. и внегалактические. Первые имеют ярко выраженную концентрацию к га-

л $L_X < 10^{30}$ эрг с^{-1} и менее. Было, наконец, обнаружено рентг. излучение корон нормальных звёзд (см. Коронный ветер). Лишь небольшая часть галактич. рентг. источников отождествлена с оптич. и радиообъектами. Среди таких источников прежде всего следует выделить тесные пары, состоящие из компактного объекта (нейтронной звезды) и нормальной звезды, как правило голубого или красного гиганта. Высокая рентг. светимость таких объектов (до 10^{39} эрг/с) связана с перетеканием вещества через впадин. точку Лагранжа от нормальной на компактную звезду (см. Палочка Роша). Далёкая пара, состоящая из вырожденной звезды и красного карлика, наблюдается как барстер. В этом случае реализуется режим *звёздного ветра*, при к-ром на нейтронную звезду выпадает небольшая часть вещества компаньона. К галактич. источникам рентг. излучения относятся также остатки вспышек сверхновых.

Исследовано св. 100 внегалактич. источников. Часть из них (ок. 50) отождествлена со *скоплениями галактик*. Их рентг. светимость объясняется наличием в скоплениях горячего газа с темп-рой 10^7-10^8 К и концентрацией $10^{-3}-10^{-4} \text{см}^{-3}$. Обнаружено также рентг. излучение нормальных, активных, *сейфертовских галактик* и *квасаров*. В ближайших *галактиках* (Большое и Малое Магеллановы Облака, М 31, М 33) удалось исследовать рентг. объекты, аналогичные галактическим. Природа наблюдаемого рентг. фонового излучения до конца не ясна. Вероятно, его значит. часть объясняется суммарным излучением неразрешённых слабых внегалактич. источников, находящихся на больших расстояниях.

Лит.: Иосифовичи и техникум, сер. Астрономия, т. 9, М., 1974; Москаленко Е. И., Методы внеатмосферной астрономии, М., 1984; Лонгфелло Р. М., Астрофизика высоких энергий, пер. с англ., М., 1984.

РЕНТЕГОНОВАЯ КАМЕРА — прибор (или осн. часть установки) для изучения и контроля атомной структуры образца с помощью регистрации картины распределения рассеянного излучения при дифракции рентг. лучей на исследуемом образце. Применяется в *рентгеновском структурном анализе, рентгенографии материалов, рентгеновской томографии*.

В Р. к. используется рентг. излучение рентг. трубки или *синхротронное излучение*. Дифракц. картина фиксируется на высокочувствит. рентг. фотоплёнке или регистрируется к.-д. детектором частиц (напр., электронно-опич. преобразователем).

Назначение Р. к. — обеспечить такое расположение и перемещение образца относительно направления первичного рентг. пучка, при к-рых выполняются условия дифракции рентг. лучей и возможно получение рентгенограмм от данного образца.

В соответствии с разл. методами рентгеноструктурного анализа различны и геом. схемы рентгенографирования в Р. к. Эти схемы учитывают размеры, форму и положение образца, положение и размеры фокуса рентг. трубки и щелей коллиматора, положение и радиус изгиба монохроматора, форму, размеры и положение кассеты. Все эти данные должны быть согласованы между собой с высокой точностью, чтобы обеспечить оптич. условия рентгенографирования.

Для исследования монокристаллов используют Р. к. вращения-колебания, Р. к. для получения *лауэграмм*

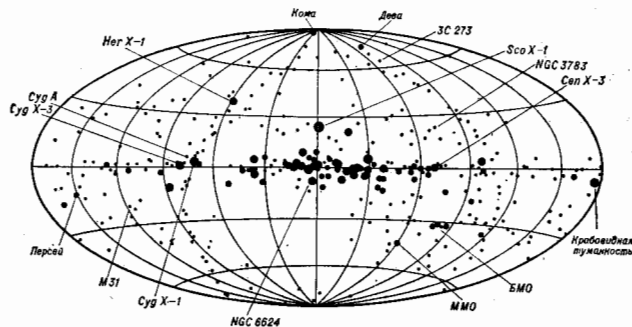


Рис. 3. Распределение рентгеновских источников по небу в галактических координатах (по данным 4-го каталога «Ухуру»). Указаны наиболее яркие источники.

лактич. плоскости и к центру Галактики (рис. 3). Рентг. светимость L_X ярких (с потоком св. 10 единиц «Ухуру») источников (ок. 100 шт.) заключена в пределах $3 \cdot 10^{33}-3 \cdot 10^{37}$ эрг с^{-1} . Слабые источники с $L_X \sim 10^{30}-10^{34}$ эрг с^{-1} и потоком менее 5 единиц «Ухуру» меньше концентрируются к плоскости и центру Галактики. Обсерватория имени Эйштейна («ХЕАО-2») позволила наблюдать ещё $\sim 10^3$ галактич. источников

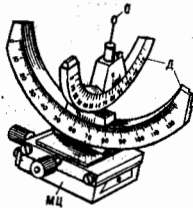
и эпиграмы, рентг. гониометры. Структуру поликристаллов изучают в дебаевских Р. к. (Дебая — Шеррера метод), в Р. к. обратной эвэмки, в камерах с фокусирующей реал. типа и др. В рентг. топографии применяются камеры Ланга, Шульца, Фудживара, Брэтта — Баррета и др. (по именам авторов, представляющих соответствующую геометрию рентгенографирования). Для исследования аморфных и стеждообразных тел, а также растворов, дифракц. излучение от к-рых сосредоточено вблизи первичного (неотклоненного) пучка, т. е. под малыми углами, служат малотугольные Р. к. (см. Малоугловое рассеяние). Существуют также спец. камеры для рентгенографирования при низких или высоких темп-рах, высоких давлениях, в условиях вакуума и т. п.

Все Р. к. содержат коллиматор, узел установки образца, кассету с фотоплёнкой, механизм движения образца, а при необходимости и движения кассеты в процессе рентгенографирования, узел крепления камеры у рентг. трубки. Часто в состав Р. к. входят вспомогат. устройства, напр. простую счётчиковую систему, обеспечивающую предварит. установку образца, блок регистрации темп-ры образца и её программируемого задания.

Коллиматор формирует рабочий пучок первичного излучения — квазипараллельный или с заданной расходимостью. С коллиматором может быть совмещён кристалл-монокроматор, выделяющий излучение нужного спектрального состава. В Р. к., использующих синхротронное излучение, для подавления гармоник служат зеркала полного отражения. В конструкциях коллиматора предусмотрены устранение излучения, рассеянного от краёв формирующих пучок деталей, а также возможность установки селективно поглощающих фильтров.

В Р. к. для изучения монокристаллов образец обычно закрепляют в гониометрич. головке (рис. 1). В ней отцентрированный относительно пучка образец можно поворачивать вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, отсчитывая углы поворота по шкалам, и помещать образец в процессе рентгенографирования. Т. о. выводит кристаллографич. плоскости в отража-

Рис. 1. Гониометрическая головка: О — образец; Д — дуговые направляющие для наклона образца во взаимно перпендикулярных направлениях; МП — механизм центрировки образца, служащий для выведения центра дуг, в котором находится образец, на ось вращения камеры или на ось коллиматора.



щее положение в соответствии с геометрией используемого метода. Узел установки образца в камере для поликристаллов, кроме фиксации образца, обеспечивает его вращение относительно оси цилиндрич. кассеты или в плоскости образца (для плоских образцов). Для снятия проявления крупнокристалличности на дебаевграмме предусмотрено поступат. перемещение образца.

Кассеты Р. к. обеспечивают строго определ. расположение фотоплёнки при рентгенографировании. Форма кассеты (плоская, цилиндрическая или состоящая из секций) определяется геометрией используемого метода (рис. 2). Большой диаметр кассеты при правильной форме схемы (постиривке) даёт обычно более высокую точность измерений.

Для исследования поликристаллич. образцов (рис. 3) применяют как параллельные (дебаевские Р. к.), так и расходящиеся (фокусирующие Р. к.) первичные пучки. В последнем случае в рентгенографировании участвует

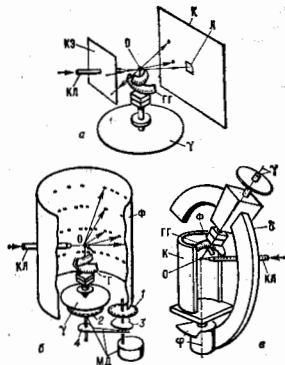


Рис. 2. Схемы расположения узлов основных типов рентгеновских камер для исследования монокристаллов: а — камера для исследования монокристаллов по методу Деау; б — камера вращения-колебания; вращение образца осуществляется с помощью шестерёнок 1 и 2, колебание — через канавки 3 и рычаг 4; в — рентгеновская камера гонистат для определения размеров и формы элементарной ячейки. Механизм установки камеры у рентгеновской трубки и экраны защиты от рассеянного излучения на схеме не показаны. О — образец; ГГ — гониометрическая головка; у — лимб и ось поворота гониометрической головки; КЛ — коллиматор; К — кассета с фотоплёнкой; КЭ — кассета для съёмки эпиграмы (обратная съёмка); МД — механизм вращения и колебания образца; ф — лимб и ось колебания образца; б — дуговая направляющая наклонно оси гониометрической головки; СЛ — слоевые линии рентгенограмм.

большая поверхность образца, что повышает светосилу прибора. Широко расходящийся пучок используется также при исследовании дефектов кристаллич. структуры почти совершенных монокристаллов.

Однозначность регистрации рентг. отражений монокристалла реализуется в рентгеновских гониометрах за

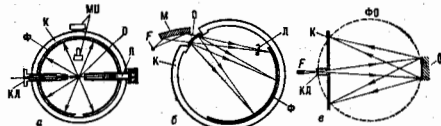


Рис. 3. Схемы расположения узлов основных типов рентгеновских камер для исследования поликристаллов: а — дебаевская камера; б — фокусирующая камера с изогнутым кристалломонокроматором для исследования образцов «на просвет» в области «средних» углов дифракции; в — фокусирующая камера для обратной эвэмки (большие углы дифракции) на плоскую кассету. Стрелками показаны направления прямого и дифрагированного пучков. Механизм движения образца, установка камеры у рентгеновской трубки и защита от рассеянного излучения на схеме не приведены. О — образец; Ф — фокусировочной трубки; М — кристалл-монокроматор; К — кассета с фотоплёнкой; ФД — линзовая, перехватывающая первичный пучок; ФО — окружность фокусироваия дифракционных максимумов; КЛ — коллиматор; МП — механизм центрировки образца.

счёт развёртки отдельной слоевой линии на плоскость плёнки. Достигается развёртка установкой в камере экрана, выделяющего поле только одной слоевой линии, и синхронным вращением и смещением кассеты (поступат. перемещение или вращение).

Р. к. используют в структурном анализе в том случае, когда исследуют пространственное распределение фракц. излучения в значит. области углов дифракции.

Дифракция в узком интервале углов с высокой точностью изучают с помощью более сложной (и более дорогой) аппаратуры — рентгеновских дифрактометров.

Лит.: У м а и с к и й М. М., Аппаратура рентгеноструктурных исследований, М., 1960; Г и н е А., Рентгенография кристаллов, пер. с франц., М., 1961; Ф и н к е л ь В. А., Высоко-температурная рентгенография металлов, М., 1968; его же, Низкотемпературная рентгенография металлов, М., 1971.

В. В. Зубенко.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛИТОГРАФИЯ — метод микроэлектронной технологии, заключающийся в формировании с субмикронным разрешением защитной маски заданного профиля на поверхности подложки; осуществляется при помощи рентг. излучения длинной волны $\lambda \sim 0,4\text{--}5$ нм; один из методов *микролитографии*. Маска изготавливается из стойкого к технол. воздействию материала — полимерного резиста; необходимый рисунок формируется с помощью рентгеношаблона. Поток рентг. излучения направляют на рентгеношаблон (рис. 1), к-рый этот поток пространственно модули-

рует. Резист поглощает попавшее на него излучение, т. е. в нём формируется скрытое изображение рентгеношаблона; под действием излучения в резисте образуются высокоэнергетические (с энергией $\phi \sim 1$ кэВ) фото- и оже-электроны, к-рые вызывают сшивание молекул резиста или их деструкцию. В зависимости от того, какой из процессов преобладает, при проявлении на подложке остаются либо облучённые, либо необлучённые участки, т. е. получается негативное или позитивное изображение рисунка шаблона (рис. 2). Соответственно резисты делятся на негативные и позитивные. Благодаря малой длине волны λ рентг. излучения методы Р. л. обладают высокой разрешающей способностью (~ 10 нм). По сравнению с электронно- и фото-литографией в Р. л. малы радиус. повреждения формируемых структур и высока производительность благодаря возможности одноврем. обработки больших площадей образца. Р. л. отличается большой глубиной резкости и малым влиянием материала подложки и её топографии на разрешающую способность.

Разрешающая способность Р. л. определяется несколькими факторами. Основные из них: дифракционное $\delta_1 = \sqrt{S\lambda}$, полугетовое $\delta_2 = S(d/L)$ (обозначения см. на рис. 1) и фотоэлектронное $\delta_3 \approx \phi^{1,25}$ размытия границ скрытого изображения. Величина δ_3 определяется длиной пробега фото- и оже-электронов в резисте и зависит от состава резиста и λ (рис. 3). Полугетовое размытие можно в достаточной степени уменьшить подбором значений S , d и L . Теоретически предельная разрешающая способность Р. л. (контактное экспонирование; $S = H_0$, где H_0 — толщина резиста) достигается при $\lambda \approx 5$ нм и составляет ок. 5 нм. Разрешение, близкое к предельному (17,5 нм), получено при экспонировании позитивного резиста — полиметилметакрилата (ПММА) излу-

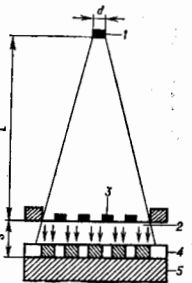
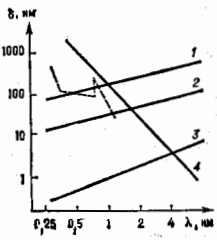


Рис. 2. Сфотографированная тестовая структура с шириной линии 0,3 мкм, сформированная методом рентгеновской литографии в позитивном резисте толщиной 3 мкм, полученная в растворе электронного микроскопа (РЭМ-фотография).

нием $S_{K\alpha}$ ($\lambda = 4,48$ нм). Для того чтобы электрофиз. характеристики элементов интегральных схем имели разброс в допустимых пределах, необходимо, чтобы точность воспроизведения размеров элементов составляла не менее 10% от их ширины, т. е. разрешающая способность метода должна превышать мин. размеры элементов.

Рис. 3. Зависимость дифракционного и фотоэлектронного пределов разрешения от λ . Дифракционное размытие приведено для величин выворота 1 и 25 мкм, а также для случая контактного экспонирования — прямые 1, 2 и 3 соответственно; 4 — зависимость эффективного пробега фотоэлектронов в органическом резисте; пунктирная кривая — участок аналогичной зависимости для резиста, в состав которого для увеличения поглощения излучения введены атомы кремния. Вблизи начного поглощения ход зависимости нелинейный, но так как с резким уменьшением энергетического спектра фото- и оже-электронов.



Р. л. предъявляет высокие требования к рентгеношаблонам. Пленка шаблона при достаточной высокой механич. прочности и стабильности должна пропускать не менее 50% излучения (что возможно при толщине ~ 1 мкм), а нанесённое на неё маскирующее покрытие быть высококонтрастным — сильно (на порядок) ослаблять поток излучения, толщина же покрытия не должна



Рис. 4. Зависимость коэффициента поглощения рентгеновского излучения материалами, используемыми для изготовления рентгеношаблонов, и стандартного резиста (ПММА) от λ .

превышать 1 мкм, т. к. в более толстом маскирующем покрытии затруднено формирование рисунка с субмикронными размерами.

Для излучения с $\lambda < 0,3$ нм отсутствуют материалы для изготовления высококонтрастного маскиру-

щего покрытия, а при $\lambda > 1,5$ нм поглощение мембраны шаблонов слишком сильно (рис. 4). Исключение составляют лишь полимерные плёнки в диапазоне длин волн 4,2—6 нм. Наиб. распространение получили мембраны из кремния и его соединений — карбида, нитрида и оксинитрида. Используются также мембраны из нитрида бора, бериллия, полимеров — полиимида и парилена, а также комбинированные (нитрид бора — полиимер и др.).

Реактивные плёнки для Р. л. формируют на подложке из раствора полимера методом центрифугирования. После сушки, в процессе к-рой удаляется растворитель, плёнку облучают и обрабатывают в жидком проявителе. Осн. характеристики резиста — чувствительность, контрастность, разрешающая способность и стойкость к последующим технол. процессам, в частности к плазмохим. травлению. Возможны и «сухие» методы нанесения резистов (плазменная полимеризация, термич. напыление) и проявления изображения в них (плазмохим. и УФ-травление, сублимация в вакууме). Рассматривается возможность применения и неорганич. материалов, напр. халькогенидных стёкол.

Благодаря большой проникающей способности рентг. излучения, малости эффектов рассеяния и высокого контраста при экспонировании Р. л. позволяют формировать в резистах субмикронные структуры с большим отношением высоты к ширине, а также формировать в однослойных резистах структуры со сложным профилем края (рис. 5), напр. нависающим. Последнее достигает



Рис. 5. РЭМ-фотографии структур с различным профилем края, сформированных в позитивном резисте.

ся за счёт дополнит. экспозиции тонких слоёв резиста фотоэлектронами на подложке либо из шаблона. Перспективно применение двухслойных и трёхслойных резистов, значительно расширяющих возможности формирования структур со сложным профилем (рис. 6).

В установках Р. л. 1-го поколения в качестве источников излучения служат рентг. трубки с неподвижным либо вращающимся водоохлаждаемым анодом мощностью в неск. кВт. Материалы анодов (в их λ) — Cu (1,33 нм), Al (0,834), Mo (0,54 нм), Pd (0,434 нм). Экспонирование осуществляется в вакуумной камере либо в атмосфере гелия. Недостаток таких источников — низкая проявляемость, обусловленная малым коэф. преобразования энергии электронного пучка в мягкое рентг. излучение ($\sim 10^{-6}$). Более производительны установки 2-го поколения, в к-рых точечными источниками излучения являются плазма, возбуждаемая лазерным излучением, или силовоточный разряд в газе.

Широкие возможности для Р. л. предоставляет использование синхротронного излучения накопит. колец на энергию 0,6—1 ГэВ с расположенными на них литограф. станциями (св. 10 на каждом накопит. кольце).

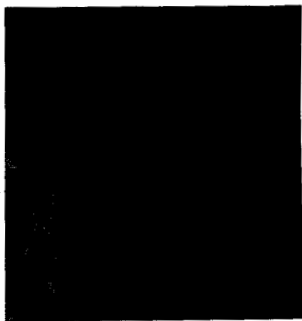


Рис. 6. РЭМ-фотографии структур со сложным профилем края, сформированных в двух- и трёхслойном резисте.

Высокая интенсивность и хорошая коллимация синхротронного излучения позволяют создавать пром. системы с разрешением $\sim 0,1$ мкм при малых временах экспозиции и упрощают проведение операции совмещения маркерных знаков с точностью $\sim 0,02$ мкм и рисунков (с точностью $\sim 0,1$ мкм) на больших площадях. Дальнейший прогресс в области источников излучения для Р. л. связан с разработкой компактных синхротронов с электромагнитами из сверхпроводящих материалов.

Лит.: Speers D. L., Smith H. I., X-Ray Lithography: a new high resolution replication process, «Solid State Technology», 1972, т. 13, № 7, р. 21; А р к о в В. В. и др. Перспективы использования мягкого рентгеновского излучения в субмикронной литографии. «Поверхность. Физика, химия, механика», 1983, № 11, с. 5. В. В. Аристов, В. А. Кудряшов.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА — область исследований, в к-рой изучаются явления и процессы распространения рентг. излучения при его взаимодействии с веществом, а также разрабатываются элементы для рентг. приборов. При рассмотрении вопросов Р. о. рентг. диапазон условно делят на 3 области длин волн λ : область жёсткого — ЖР ($0,01 < \lambda < 1$ нм), мягкого — МР ($1 < \lambda < 30$ нм) и ультратяжёлого — УМР ($30 < \lambda < 100$ нм) рентг. излучения.

Оптика, характеристики веществ в рентг. диапазоне обладают рядом особенностей. Во-первых, в рентг. диапазоне все атомы обладают низкой поляризуемостью по сравнению с более ДВ-диапазонами спектра (см. Поляризуемость рентгеновская). Рентг. кванты взаимодействуют с электронами внутр. оболочек атомов, причём для большинства электронов их энергия связи ϵ_i меньше энергии рентг. кванта $h\omega$ (ω — круговая частота излучения). За исключением узких областей близки точных резонансов вклад фотон-электронного взаимодействия в диэлектрич. проницаемость значительно меньше, чем вклад оптич. электронов в видимой и ИК-областях (см. Дисперсия света). По этой причине показатель преломления n в рентг. области для всех веществ мало отличается от 1 и почти во всём диапазоне $|n| < 1$ (только для нек-рых металлов в УМР-области $|n| > 1$). Элементы типа линз и призм в Р. о. практически не используются. Так, напр., собирающая линза из никеля с радиусом поверхности $r = 1$ см при $\lambda = 0,1$ нм должна иметь фокусное расстояние ~ 100 м.

Вторая особенность взаимодействия рентг. излучения с веществом — значит. фотопоглощение, связанное с большой вероятностью фотоеффекта, при к-ром рентг. квант выбивает один из внутр. электронов атома. Величина линейного коэф. поглощения μ растёт с λ и особенно велика в МР- и УМР-областях (для твёрдых материалов $\mu \sim 10^2 - 10^3$ см $^{-1}$), поэтому слой веще-

ства толщиной в десятки м в РР-области и в несколько мкм в УМР-области спектра являются практически непрозрачными. Слой атмосферы воздуха толщиной менее 1 см полностью поглощает рентг. излучение с $\lambda > 1$ нм, поэтому рентгенооптические приборы РР- и УМР-диапазонов могут работать только в вакууме. В ЖР-области поглощение воздуха в масштабах обычных лаб. установок незначительно.

Как внутр. структура вещества, так и неоднородности границы раздела влияют на распространение рентг. излучения, причём характер взаимодействия зависит от соотношения между λ и размером структурных неоднородностей a . В этой связи могут быть рассмотрены 2 группы явлений: Р. о. однородных и неупорядоченных сред в Р. о. сред с упорядоченной структурой (дифракц. оптика).

Рентгеновская оптика однородных и неупорядоченных сред

По отношению к рентг. излучению однородными могут считаться вещества с аморфной структурой, а также кристаллы в случае, когда постоянная решётки $a \ll \lambda$. В предположении идеально гладкой поверхности раздела сред рассматриваются френелевское отражение и преломление рентг. излучения. В тех случаях, когда граница раздела сред неидеальна, т. е. имеются локальные отклонения профиля границы от ср. линии (шероховатости) или имеется неоднородный градиент диэлектрич. проницаемости в глубь среды, возникает рассеяние падающего рентг. излучения на границе раздела. При прохождении рентг. излучения через среду, содержащую нерегулярно расположенные структурные неоднородности с линейными размерами $a \gg \lambda$ (частицы др. вещества, дефекты кристаллич. решётки и т.д.), наблюдается *малогоугольное рассеяние*.

Френелевское отражение рентг. излучения, как и в оптике более ДВ-диапазона, связано с величиной n . В общем виде в рентг. области

$$n = 1 - (\delta + i\beta), \quad (1)$$

где δ и β — т. н. рентг. оптич. константы, к-рые могут быть представлены через *атомные факторы* рассеяния f_1 и f_2 :

$$\delta = A(\lambda)f_1, \quad \beta = A(\lambda)f_2,$$

где

$$A(\lambda) = (2\pi)^{-1} N_0 r_e \lambda^2,$$

здесь N_0 — плотность атомов, $r_e = e^2/mc^2$ — классич. радиус электрона. По порядку величины δ и β изменяются от $\sim 10^{-6}$ – 10^{-8} в ЖР-области до $\sim 10^{-2}$ – 10^{-1} в УМР-области рентг. диапазона. В случае чистых металлов величину δ можно оценить с помощью соотношения $\delta = 5,4 \cdot 10^{-4} (Z\rho/AZ)^2$, где Z — ат. номер, ρ — плотность вещества в г/см³, AZ — ат. вес, λ выражена в нм. Величина β связана с μ соотношением $\beta = \lambda\mu/4\pi$.

Отражение рентг. излучения на идеально гладкой поверхности раздела однородная среда — вакуум для s - и p -поляризации (см. *Поляризация света*) характеризуется коэф. отражения R_s и R_p соответственно, рассчитываемыми по *Френеля формулам*. Если пренебречь поглощением излучения внутри среды (это в большей степени справедливо в ЖР-области), *Снелла закон* для рентг. излучения запишется в виде

$$\cos \theta / \cos \theta' = n = 1 - \delta, \quad (2)$$

где θ и θ' — скользкие углы падения и преломления. Для рентг. излучения $|\delta| < 1$, поэтому $\theta' < \theta$. При больших значениях δ френелевский коэф. отражения очень мал; при нормальном падении для всех веществ он не превосходит 10^{-3} для $\lambda \sim 10$ нм и быстро падает

с уменьшением λ . Вследствие этого обычные зеркала нормального падения с однородными покрытиями неприменимы в рентг. диапазоне длин волн. При очень малых δ значение θ' оказывается минимальным, т. е. излучение не входит в среду, а полностью отражается. Это явление наз. *полным внешним отражением* по аналогии с полным внутр. отражением в оптике видимого диапазона. При условии $\cos \theta' = 1$, т. е. когда преломляющий луч скользит по границе раздела, угол $\theta = \theta_c$ наз. *критич. углом полного внеш. отражения*: $\cos \theta_c = 1 - \delta$, $\theta_c \approx \sqrt{2\delta}$. Т. о., рентг. излучение отражается от идеально гладкой поверхности однородных сред только при падении под скользкими углами $\theta < \theta_c$, к-рые для любых веществ изменяются от долей градуса в ЖР-области до 10–20° в УМР-области спектра. При таких углах различие в коэф. отражения для разных поляризаций практически отсутствует, поэтому вводится один френелевский коэф. отражения $R(\theta)$.

При учёте поглощения величина R зависит также и от β , в частности вид зависимости $R(\theta)$ определяется их обр. отношением β/δ (рис. 1). Т. к. коэф. отражения

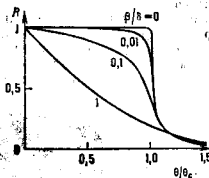


Рис. 1. Зависимость френелевского коэффициента отражения R при скользком падении от отношения θ/θ_c при различных значениях β/δ .

падает с уменьшением λ , для каждого материала и определ. угла θ существует КВ-граница отражения $\lambda_{от}$. Эта особенность используется в *отражат. фильтрах* скользкого падения, отсекающих КВ-часть излучения. Напр., в качестве таких фильтров могут служить зеркала из Al ($\lambda_{от} \approx 1,2$ нм, $\theta > 2^\circ$), Ni ($\lambda_{от} \approx 1,9$ нм, $\theta > 4,5^\circ$), Sr ($\lambda_{от} \approx 2,8$ нм, $\theta > 5^\circ$) и др.

Рассеяние при отражении в рентг. области от шероховатой поверхности среды — результат интерференции вторичных волн от элементарных излучателей в тонком приповерхностном слое вещества. В случае *малого рассеяния* (см. выше) угл. распределение (*индикатриса*) отражённого излучения содержит две компоненты: *зеркальный пик*, соответствующий отражению от идеально гладкой поверхности и *повторный* распределение интенсивности в падающем луче, и широкую диффузную компоненту, распределение интенсивности в к-рой определяется свойствами рассеивающей поверхности.

При случайном характере шероховатости интегральный поток рентг. излучения I_{Σ} , рассеянный поверхностью однородной среды, и угл. профиля диффузной компоненты $\Delta\Phi$ при определ. условиях связаны с микрогеометрич. поверхности соотношениями

$$I_{\Sigma} = I_0 \exp \{ -(4\pi \sigma \sin^2 \theta/\lambda)^2 \}, \quad (3)$$

$$\Delta\Phi \sim \lambda/\pi a \sigma, \quad (4)$$

где I_0 — интенсивность падающего пучка, σ и a — среднеквадратичная высота и коррелир. радиус шероховатостей (определяется характерным масштабом изменения f -ции корреляции профиля поверхности). Из (3) следует, что хорошие рентг. зеркала должны иметь *очень гладкую поверхность*. Напр., для того чтобы рассеяние не превышало 10% при $\lambda = 1$ нм и $\theta = 1^\circ$, значение σ не должно превышать 1,5 нм. Опыт показывает, что обычная оптич. полировка даёт поверхность с шероховатостями в пределах неск. нм, суперполировка (или т. в. глубокая полировка) —

менее 1 нм. Значения радиусов корреляции, как правило, заключены в пределах от долей мкм до неск. десятков (иногда сотен) нм. Более точная теория рассеяния, рассматривающая в приближении теории возмущений модель шероховатой поверхности как неоднородный слой, формирующего отражающую волну, даёт более сложную зависимость интенсивности и индикатриссы рассеяния от параметров пучка и геометрии поверхности. В частности, в практически наиболее важном случае относительно больших радиусов корреляции и углов скольжения, близких к θ_c , индикатрисса рассеяния имеет симметричный вид и её максимум совпадает с зеркальным пиком. При очень малых α рассеяние практически полностью концентрируется в области критич. угла отражения при любых θ (при $\theta > \theta_c$ это проявляется в виде т. я. эффекта Ионеды: индикатрисса рассеяния имеет два пика — зеркальный, смещающийся с изменением θ , и диффузный, остающийся при этом в положении, соответствующем $\theta = \theta_c$).

На френелевском отражении основаны зеркала скользящего падения (ЗСП), применяемые для концентрации излучения в рентг. каналах синхротронов, микроанализаторах, камерах малоугольного рассеяния, рентгеноискателях и др. приборах. Обычно используют вогнутые сферические, цилиндрические, тороидальные или эллиптические ЗСП, а также параболоиды и эллипсоиды вращения. Недостаток одиночных ЗСП — большие аберрации, гл. обр. астигматизм в coma, к-рые ограничивают в конечном итоге светосилу и предел концентрации излучения.

Для построения изображений самосветящихся или просвечиваемых объектов в рентг. телескопах и рентг. микроскопах применяются системы из двух или больше-

лом скольжения и длинной зеркал, ограниченной вследствие роста аберраций. Для увеличения светосилы используют «геодеобразные» системы из вложенных друг в друга пар зеркал с общим фокусом. Предельным случаем являются системы из неск. десятков или сотен очень коротких двойных конв. колец, для к-рых качество изображения определяется в осн. шириной кольца, а коэф. использования площади входного отверстия достигает 50% и более. Эфф. светосила ЗСП зависит также и от коэф. отражения покрытия $R(\theta)$, к-рое подбирается исходя из максимума произведения $\theta \cdot R(\theta)$ для заданного диапазона длин волн. В МР- и УМР-диапазонах наиб. часто используют покрытия из никеля и золота, имеющие наиб. значения $\theta \cdot R(\theta)$.

Особый тип ЗСП — зеркала с многократным отражением, работающие по принципу ешпущей галереи. Если направить пучок рентг. излучения под углом $\theta < \theta_c$ к поверхности изогнутого зеркала, то в результате многократных отражений от неё пучок можно повернуть на значит. угол ϕ , к-рый может составлять десятки градусов. Коэф. отражения при этом определяется λ , оптич. константами материала зеркала, ϕ и шероховатостью отражающей поверхности. Он оказывается на неск. порядков больше, чем при однократном отражении с поворотом на тот же угол. Этот принцип применяется и в рентг. волноводах (обычно изготовляемых из кварцевых итенидных капилляров), к-рые можно использовать для передачи излучения на расстоянии в десятки см и преобразования пучков амалогично волоконным светодам видимого диапазона.

Рентгеновская оптика сред с упорядоченной структурой

В том случае, когда структура вещества упорядочена и характерный период структуры $a \sim \lambda$, интерференция когерентных волн, дифрагировавших на элементах структуры, приводит к концентрации рассеянного излучения в нек-рых дискретных направлениях, в к-рых волны складываются в фазе; интенсивность этого излучения пропорц. квадрату числа элементов структуры. В рамках такого дифракц. подхода рассматриваются брэгговская оптика кристаллов, оптика многослойных отражающих покрытий, микроструктурная рентг. оптика. В первом случае в качестве рентгенооптик. элементов используют кристаллич. структуры, в последних двух — искусственно созданные объёмные или поверхностные структуры — зеркала нормального падения с многослойными покрытиями, отражательные и пропускающие дифракц. решётки, зонные пластинки Френеля, брэгг-френелевские отражатели.

Брэгговская оптика кристаллов. При взаимодействии рентг. излучения с кристаллом, когда выполняются условия Брэгга — Вульфа, возникает брэгговское отражение (см. Дифракция рентгеновских лучей). Это явление легко в основу рентгено-спектральных методов (см. Рентгеновская спектральная аппаратура), а также методов рентгеновской топографии. Диапазон спектра, в к-ром может использоваться тот или иной кристалл, определяется постоянной решётки $2d$ и диапазоном изменения (обычно от 3—5° до 60—70°) угла Брэгга θ (угла между плоскостью кристалла и направлением падающего пучка). Кристаллы со структурой, близкой к идеальной, имеют наиб. высокую разрешающую силу $\delta/\Delta\delta$ (δ — энергия рентг. кванта, $\Delta\delta$ — энергетич. ширина максимума отражения) при сравнительно небольшом значении интегрального коэф. отражения $R_c = \int R(\theta) d\theta$. Напр., кристалл кварца при отражающей плоскости (1011), ($2d = 0,6886$ нм) имеет $R_{c \max} = 1,23 \cdot 10^{-4}$ и $\delta/\Delta\delta_{\max} = 7700$, при отражающей плоскости (2023), ($2d = 0,2750$ нм) $R_{c \max} = 1,5 \cdot 10^{-3}$ и $\delta/\Delta\delta_{\max} = 4 \cdot 10^3$. Монокристалл графита [плоскость (002), $2d = 0,6708$ нм] имеет $R_{c \max} = 1,52 \cdot 10^{-3}$ и $\delta/\Delta\delta_{\max} = 113$.

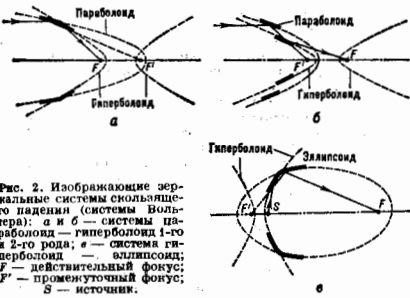


Рис. 2. Изображающие зеркальные системы скользящего падения (системы Вольтера): а и б — системы параболаид — гиперболаид 1-го и 2-го рода; в — система гиперболаид — эллипсоид; F — действительный фокус; F' — промежуточный фокус; S — источник.

го числа ЗСП. Простейшая из таких систем — система индикатрисса — Базаа — состоит из пары скрещенных сферич. или цилиндрич. зеркал (см. Рентгеновский микроскоп, п. 2).

Высоким разрешением и значительно большей, чем скрещенные системы, светосилой обладают системы глубоко асферических осесимметричных ЗСП с отражающими поверхностями, имеющими форму параболоидов, гиперболоидов и эллипсоидов вращения. Для компенсации аберраций число зеркал в таких системах должно быть чётным. Наиб. распространены т. я. системы Вольтера (рис. 2): параболаид — гиперболаид, используемая в рентг. телескопах, и система гиперболаид — эллипсоид, применяемая в рентг. микроскопах. Принцип построения систем Вольтера состоит в том, что промежуточное мнимое изображение источника строится в общем фокусе 1-го и 2-го зеркал, а результирующее действительное — в сопряжённом фокусе 2-го зеркала.

Геом. апертура систем Вольтера представляет собой кольцевое отверстие, ширина к-рого определяется уг-

Для повышения R_n , а следовательно, и светосилы прибора за счёт некоего снижения разрешающей силы используют мозаичные кристаллы, состоящие из множества отд. блоков, кристаллограф. плоскости к-рых слегка развёрнуты друг относительно друга.

Рентгеноопт. элементы на основе кристаллов могут быть плоской, цилиндрич., сферич. или асферич. формы, к-рая им придаётся изгибом и полировкой в спец. оправках или наклеиванием (выращиванием) тонких кристаллов на подложку требуемой формы.

Дифракция ЖР-излучения на совершенном кристалле благодаря регулярному расположению атомов кристаллич. структуры носит динамич. характер (динамич. дифракция; см. Дифракция рентгеновских лучей). Это означает, что многократное рассеяние излучения на кристаллич. плоскостях сохраняет свои когерентные свойства, в результате чего амплитуда дифрагиров. волн становится сравнимой с амплитудой проходящей волны. Интерференция дифрагированных и проходящей волн приводит к образованию результирующего волнового поля в кристалле, к-рое может быть представлено в виде суперпозиции волн, полученных нав. б л о к о в с к и х. Эфф. длина блоховской волны в кристалле принимает значение от единиц до десятков мкм, что существенно снижает требования к изготовлению рентгеноопт. элементов.

Рентгеноопт. прибором, использующим братговскую дифракцию, является интерферометр Боузе — Харта (рис. 3), состоящий из трёх пластинок с общим основанием, изготовленных из монокристалла (напр., Si). Расщеплённый на кристалле-разделителе S рентг. пучок сводится кристаллом-зеркалом M на анализаторе

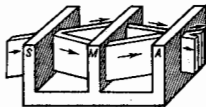


Рис. 3. Рентгеновский интерферометр Боузе — Харта.

А. Сформированная интерференц. картина обладает исключительной высокой чувствительностью к разл. рода нарушениям. Такого типа интерферометры используются для измерений показателей преломления, структурных дефектов. Применение технологии микроструктурирования позволяет изготовлять из совершенных монокристаллов сложные типы микроинтерферометров, спектральных приборов и их элементов.

Рентгеновская оптика многослойных покрытий. В МР- и УМР-области используют зеркала с многослойными покрытиями (МСП), к-рые, в отличие от зеркал скользящего падения, могут работать при любых углах вплоть до нормального паде-

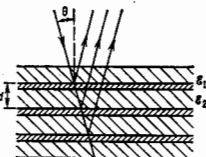


Рис. 4. Схема многослойного покрытия; ϵ_1, ϵ_2 — диэлектрические проницаемости 1-го и 2-го интервалов.

ния. Такие зеркала широко применяются в приборах для фокусировки излучения и построения изображений, спектрального анализа и поляриметрии, в резонаторах рентг. лазеров, в качестве делителей пучков и т. п. МСП (рис. 4) представляет собой периодич. структуру из чередующихся слоёв веществ с разл. значением диэлектрич. проницаемости ϵ_1 и ϵ_2 , нанесённых

на подложку таким образом, что период d постояен и не изменяется по опред. закону. При больших углах скольжения коэф. отражения от каждой границы раздела несевил, но благодаря сложению сифазных волн, отражённых от неск. десятков или сотен слоёв, полн. коэф. отражения покрытия может составлять десятки процентов. Условие, при к-ром достигается максимум коэф. отражения МСП для монохроматич. излучения, с точностью до отличия показателя преломления от 1 совпадает с условием Брэгга — Вульфа: $2d \cos \theta = m \lambda$ (θ — угол падения, m — порядок интерференции). Т. о., МСП представляет собой искусственный одномерный кристалл, причём, в отличие от обычных кристаллов, период структуры может быть задан произвольно в широких пределах (от сотен до единиц нм).

В МСП возможны два механизма отражения. Первый — интерференц. отражение, реализуемое, когда поглощение в обоих веществах мало и выполняется условие $|\text{Re}(\epsilon_1 - \epsilon_2)| \gg \text{Im}\epsilon_1$; в этом случае величина макс. коэф. отражения МСП определяется скачком действит. части ($\epsilon_1 - \epsilon_2$). Второй — отражение вследствие эффекта Бормана (см. Аналогичного преломления эффект); в этом случае вещества подбираются так, чтобы выполнялось условие $\text{Im}\epsilon_2 \gg \text{Im}\epsilon_1$, к коэф. отражения определяется скачком мнимой части ϵ . Такая структура состоит из очень тонких слоёв сильно поглощающего вещества и дополняющих их до периода d слоёв вещества со слабым поглощением. При резонансном отражении в структуре образуется стоячая волна, узлы к-рой приходятся на слои вещества с большим поглощением, и поэтому затухание в них мало. Реально в отражении участвуют в той или иной мере оба механизма, поэтому необходимо подобрать опт. соотношение толщин слоёв в пределах заданного периода.

Отражение от зеркала с МСП, в отличие от зеркала скользящего падения, узкополосно. Разрешающая способность определяется числом эффективно отражающих слоёв, к-рое, в свою очередь, зависит от коэф. отражения и поглощения слоёв, образующих элементы структуры. По спектральному разрешению, достигаемому в нек-рых случаях мн. сотен, зеркала с МСП успешно конкурируют с молекулярными кристаллами; при работе под углами, близкими к бростеровскому (в рентг. области $\Phi_{Br} \approx 45^\circ$), они являются эфф. локализаторами излучения.

С помощью МСП может быть реализована фокусирующая и изображающая Р. о. нормального падения с использованием сферич. и асферич. зеркал, подложки для к-рых изготовляются методами традиц. оптич. технологии, в то время как изготовление зеркал скользящего падения намного более сложно и трудоёмко. Ожидается, что в ближайшем будущем с помощью зеркал с МСП будет достигнуто разрешение в рентг. области, близкое к дифракционному, что в десятки раз выше достижимого в видимом диапазоне спектра. В то же время использование МСП зеркал скользящего падения, работающих в области $\lambda < 1$ нм, даёт возможность в неск. раз увеличить углы скольжения и светосилу приборов (напр., рентг. микроскопов, микроанализаторов).

Одн. методы изготовления МСП — электронно-лучевое, магнетронное и лазерное напыления на подложку слоёв тяжёлых металлов (W/Re, Mo, Ni, Ru, Ti, Au) в сочетании со слоями лёгких элементов (C, B, Be, Si). К 1993 макс. значения коэф. отражения при нормальном падении (~ 70–80%) достигнуты в УМР-области ($\lambda \sim 13$ –20 нм) для структуры Mo — Si, изготовленной магнетронным напылением; разрешающая способность таких систем составляет 10–20. Наиб. разрешение (200–300) достигнуто для структуры из 400–800 слоёв Ni — C с $d \approx 2$ нм, напыленной электронным пучком. Именитая период структура по мере напыления МСП, можно в нек-рых пределах управлять шириной

полосы отражения. При изготовлении подложки из шести, прозрачных для рентг. излучения (напр., С, Si), удаётся создать делитель рентг. пучка, эталон Фабри — Перо (рис. 5) и т. п. оптич. элементы.

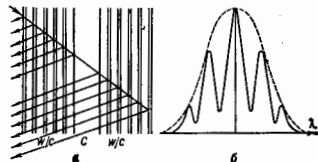


Рис. 5. Эталон Фабри — Перо для рентгеновского излучения (а), состоящий из многослойных покрытий W и C, и его кривая отражения (б).

На качество зеркал с МСП влияют погрешности формы и шероховатость поверхности подложки, межслойные шероховатости и разброс толщин слоев, неравномерная плотность слоёв и растрескивание их границ вследствие диффузии. Влияние шероховатости подложки, проявляющееся на всех слоях структуры, и шероховатостей поверхностей самих слоев проявляется в снижении коэф. отражения МСП, к-рое описывается Дебая — Уоллера фактором:

$$R = R_0 \exp \left[-\left(2\sigma/d\right)^2 \right],$$

где R_0 — коэф. отражения структуры при абсолютно гладких граничных слоёв, σ — афф. высота шероховатости слоя, МСП с наб. гладкой поверхностью слоя ($\sigma = 0,2-0,3$ нм) удаётся получить при выпалении на хорошо отполированную подложку из кремния или плавяного кварца структур типа (Re — W) — С, Ni — С, для к-рых получены МСП с наем. периодом ($d \sim 4,2$ нм).

Отражающие и пропускающие дифракц. решётки используются в МР- и УМР-областях для монохроматизации излучения и построения спектральных изображений. Дисперсионное уравнение для отражающих дифракц. решёток (ОДР) в общем случае имеет вид

$$d \sin \gamma (\sin \alpha + \sin \beta) = m\lambda,$$

где d — период решётки, γ — угол между волновым вектором падающего пучка и нормалью на плоскость дисперсии, α и β — углы между проекциями на плоскость дисперсии волновых векторов падающего и дифрагиров. пучков и нормалью к плоскости решётки. Решётка может освещаться по классич. схеме, когда падающий пучок лежит в плоскости дисперсии, и по т. н. схеме конич. дифракции, в к-рой плоскость падения пучка почти нормальна к плоскости дисперсии, т. е. пучок падает вдоль решётки. Эффективность ОДР определяется интенсивностью дифракц. пучка, зависящей от углов дифракции, периода решётки, геометрии штриха, его освещения и коэф. отражения покрытия, к-рый, в свою очередь, зависит от угла θ между направлением пучка и плоскостью отражающей грани штриха (в большинстве случаев θ не превышает $20-30^\circ$).

Преимущество классич. схемы — более высокая дисперсия, т. к. за счёт скользящего падения видимое расстояние между штрихами решётки уменьшается в $1/\sin \mu$ раз. В то же время для схемы конич. дифракции характерна более высокая эффективность, поскольку в ней отсутствует взаимное затенение штрихов.

В рентг. области наиб. часто используют ОДР с треугольным, синусоидальным или прямоуг. штрихом; в последних может быть получена концентрация излучения в определ. порядок спектра за счёт интерференции

волн, отражённых от верхней и нижней поверхностей профиля штриха. В классич. схеме наб. эффективность обладает решётки с треугольным профилем штриха — эшелетты — при выполнении условия блеска, т. е. когда падающий и дифрагиров. пучки симметричны относительно нормали к отражающей грани штриха. Макс. эффективность (теоретич.) эшелеттов с золотым покрытием и частотой 600 штрихов на 1 мм достигается при угле блеска $2,5^\circ$ и $\lambda \sim 10$ нм — св. 40%; для ОДР синусоидального и прямоуг. профиля она составляет соответственно ок. 30 и 20%. С увеличением частоты штрихов, а также при больших или меньших λ эффективность падает. Кроме того, реальная эффективность ниже теоретической в 1,5–2 раза из-за несовершенства формы штрихов и шероховатости их поверхности.

По форме ОДР могут быть плоскими, сферическими или асферическими. Вогнутые ОДР могут использоваться одновременно в качестве диспергирующего и фокусирующего элементов. Для снижения значит. aberrаций, возникающих при скользящем падении, применяют особые схемы расположения источника, решётки и детектора (напр., для сферич. решётки — схема Роуленда; см. Рентгеновая спектральная аппаратура), а также переходят к асферич. форме подложки (торцевидной, эллиптической или более высокого порядка). Для получения стигматич. изображений используют также перем. шаг и кривизну штрихов, при этом могут быть построены весьма светосильные ОДР, дающие спектральные изображения с разрешением $\lambda/\Delta\lambda \sim 10^4-10^5$ [предельное разрешение обычных сферич. решёток с регулярными прямоугольными штрихами не превышает $(2-3) \cdot 10^3$].

Совр. способы изготовления ОДР — нарезка на металле (алюминий, золото) алмазным резаком на станке с управлением от ЭВМ (макс. частота 3600 штрихов на мм; возможно получение профиля штриха с малым углом наклона при ограничениях на форму подложки), а также голографич. методы с использованием УФ-лазеров и синхротронного излучения (макс. частота — до неск. десятков тысяч штрихов на мм). Для достижения оптич. профиля штрихов — треугольного или прямоугольного — и перекоса голографич. рисунка решётки на более гладкую подложку применяют новое травление. Для полученных таким способом кварцевых ОДР с прямоуг. штрихом КВ-граница составляет ок. 0,5 мкм. С помощью рентгеновской литографии изготавливают рентгеновые ОДР с многослойными покрытиями, к-рые могут работать с высокой эффективностью при больших θ вплоть до нормального падения, однако их область дисперсии ограничена спектральной шириной максимума отражения покрытия.

Пропускающие дифракц. решётки (ПДР) изготавливаются методами микролитографии и представляют собой тонкопленочные структуры, обычно из Au, толщиной в неск. нм. Макс. эффективность дифракции зависит от λ и в 1-м порядке может достигать 5–10% при плотности штрихов от неск. сотен до неск. тысяч на 1 мм. Вследствие конечной толщины структуры существует КВ-предел применения ПДР ($\sim 0,1$ мкм), ниже к-рого решётка становится практически прозрачной. ПДР могут устанавливаться в сходящемся или расходящемся пучке совм. с фокусирующей Р. о., при этом для коррекции возникающих aberrаций шаг структуры делают переменным.

Зонные пластинки Френеля (ЗПФ) в рентг. диапазоне являются дифракц. аналогами обычных лиз и обладают наивысшим из рентгенооптич. элементов пространственным разрешением. ЗПФ как рентгенооптич. элемент предложены в 1952 А. Вазом (А. Ваез). Они служат осн. элементом в сканирующих и изображающих рентг. микроскопах с использованием синхротронного излучения. ЗПФ представляет собой искусство микроструктуру с радиально расположенными

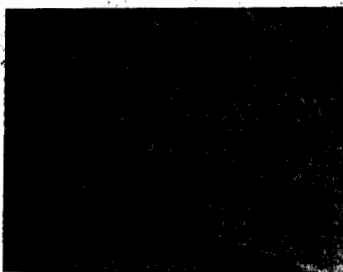


Рис. 6. Фазовая зонная пластинка из кремния на длину волн 0,83 мкм.

ми чередующимися кольцевыми, прозрачными, поглощающими или преломляющими областями, параметры к-рых связаны соотношением

$$r_n = \sqrt{nF\lambda + n^2\lambda^2/4},$$

где r_n — радиус n -й кольцевой зоны; F — её фокусное расстояние.

Эффективность ЗПФ зависит от оптич. свойств материалов и формы профиля зоны, заполненной материалом. Оптич. толщина $t_{\text{опт}}$ поглощающего (преломляющего) слоя для бинарного (прямоугольного) профиля определяется из ур-ния

$$2 \sin\left(\frac{1}{\lambda} 2\pi\delta t_{\text{опт}}\right) + 2 \frac{\beta}{\delta} \cos\left(\frac{1}{\lambda} 2\pi\delta t_{\text{опт}}\right) = \\ = 2 \frac{\beta}{\delta} \exp(-2\pi\beta t_{\text{опт}}),$$

где β и δ — оптич. константы. Эффективность ЗПФ описывается ур-нием

$$e_1 = n^{-2} [1 + \exp(-\pi\beta/\delta)^2]$$

и для сильно поглощающих материалов, напр. Au при $\lambda > 1$ мкм ($\beta \gg \delta$), не превышает n^2 . ЗПФ являются фазовыми, если изготовлены из материала с отношением $\beta/\delta < 0,1$. Так, для создания эффективных ЗПФ наилучшими свойствами обладают следующие хим. элементы: С (в интервале λ от 5,1 до 8,5 нм), Al (1,4–2,2 нм), Si (0,7–2 нм), Cu (0,4–0,5 нм), Ag (0,46–0,7 нм), Au (0,2–0,234 нм). На рис. 6 приведена фазовая ЗПФ из кремния.

Изображение, создаваемое ЗПФ, свободно от дисторсии, разрешение определяется размером последней зоны. Для создания ЗПФ применяют голографию, методом, а также электронно-лучевую литографию, плазмен. травление, селективное хим. травление материалов и т. д. Технология создания ЗПФ включает получение тонких мембран на карбиде и нитриде кремния, полн. мида толщиной от долей мкм до неск. мкм. Радиус последней зоны должен составлять 1–2 мкм с точностью до единиц нм. Размер последней зоны достигает 10 мкм. В перспективе возможно создание киноформных ЗПФ со спец. формой профиля зоны (см. Киниформа).

Достоинства обычных ЗПФ — относит. простота их изготовления, возможность массового воспроизводства, относит. простота расчёта параметров структуры элементов. Недостатки — высокие термич. и радиац. стойкости, ограничение рабочего диапазона длин волн ($\lambda \sim 0,5$ –1 мкм), отсутствие возможности создания управляемых, переключаемых элементов, ограничения на аббертуру и разрешение в связи с тем, что толщина

элементов много больше λ . В результате необходимости учёта эффекта объёмной дифракции предельное разрешение ЗПФ оценивается по ф-ле

$$b_{\text{мин}} = \sqrt{\lambda t_{\text{опт}}}$$

и составляет для разл. элементов от 50 до 100 нм.

Брагг — френелевская оптика. Использование объёмной дифракции на многослойной или кристаллич. структуре с определ. формой поверхности или изменением периода отражающих плоскостей позволяет создать оптич. элементы, совмещающие высокое пространственное разрешение ЗПФ и высокое спектральное разрешение и механич. стабильность многослойных и кристаллич. структур. Идеальная брагг-френелевская линза (БФЛ) — трёхмерная голограмма точки, представляющая собой систему эллипсоидов или параболоидов вращения границ трёхмерных зон Френеля (рис. 7). БФЛ обладает хроматич. aberrациями, фокусирует все длины волн, отражаемые решёткой, в одну точку. Однако такая система весьма трудна в реализации, т. к. требует создания очень точной формы поверхности кристалла или зеркала. Синтезированные БФЛ, обладая всеми свойствами объёмных БФЛ, позволяют использовать плоские кристаллы или многослойные зеркала. Совмещая объёмные зоны Френеля с идеальной объёмной решёткой, периодической или аперриодической, выделяя области, в к-рых положение границ системы объёмных зон Френеля и плоскостей решётки совпадают или отличаются не больше чем на четверть межплоскостного расстояния, получают структуру синтезированной БФЛ (рис. 7). Изменяя

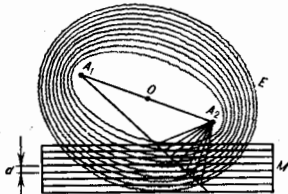


Рис. 7. Схема получения брагг-френелевской зонной пластинки: A_1 и A_2 — когерентные источники; E — эллиптические мифазные поверхности; M — многослойная структура.

коэф. отражения или фазу рассеяния от зоны к зоне, можно получить эффект фокусировки, как и в случае плоской ЗПФ. Параметрич. ур-ния пространственной структуры БФЛ:

$$z = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \left[a\xi\eta(1+k^2) - \frac{\sigma k^2}{M_0} \right],$$

$$\eta^2 = a^2(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2) - \left(ka\xi\eta - \frac{\sigma k}{M_0} \right)^2,$$

$$z = \frac{\sigma k}{M_0 \sqrt{1+k^2}},$$

где k — тангенс наклона элемента к оптич. оси, M_0 — относит. коэф. увеличения системы, $2a$ — расстояние от объекта до изображения, $\xi > 1$ и $-1 < \eta < 1$ — параметр системы, $\xi = \xi_0 + n\lambda/4$, $\xi_0 = \sqrt{(1 + k^2/M_0^2)/(k^2 + 1)}$. Трёхмерные БФЛ изготавливаются из совершенных кристаллов или зеркал с МСП. Одномерные брагг-френелевские элементы (БФЭ) с вариацией периода в объёмной структуре являются дифракц. признаками. Управляли положением отражающих плоскостей БФЭ с помощью электрич., оптич. и УЗ-сигналов, можно менять коэф. отражения и фазу отражённой

волны. Модулировать положение отражающих плоскостей можно также путём смещения плоскостей из отражающего положения, изменением параметра решётки (межплоскостного расстояния) внепл. воздействием, искажением формы поверхности кристалла в целом импульсными или волновыми процессами и путём модуляции электронной плотности в кристалле. БФЭ могут быть использованы в широком диапазоне длин волн, имеют большие механич., термич. и радиац. устойчивости. На базе управляемых БФЭ можно создавать устройства сканирования рентг. пучком, модуляции и передачи информации. БОЛ, совмещённые с интерферометрами Фабри — Перо и изготовляемые на прозрачных для рентг. излучения мембранах, рассматриваются как осн. элементы для резонаторов рентг. лазеров.

Перспективы развития Р. о. связаны гл. обр. с совершенствованием технологий изготовления рентгеноопт. элементов (получения сверхгладких зеркальных поверхностей разл. профиля, улучшения качества поверхностей многослойных покрытий, повышения разрешения микроструктур и т. д.). Наибольшие надежды возлагаются на Р. о. многослойных покрытий и брэгг-френелевскую оптику в связи с разработкой рентг. лазеров, рентг. голограмм, рентг. микроскопии и др. направлений.

Лит.: Зинакина Т. М., Фомичев В. А., Ультрамалая рентгеновская спектроскопия, Л., 1971; Burger A. J., Crystals for astronomical X-ray spectroscopy, «Space Sci. Instr.», 1976, v. 2, № 1/3, p. 53; Каули Д., Физика дифракции, пер. с англ., М., 1978; Пилис В. Г., Рентгеновская кристаллооптика, М., 1982; Рентгеновская оптика и микроскопия, под ред. Ш. Шмалля и Д. Рудольфа, пер. с англ., М., 1987; Миллетт А., Оптика мягкого рентгеновского излучения, пер. с англ., М., 1989; Зеркальная рентгеновская оптика, под ред. А. В. Виноградова, Л., 1989; Аристова В. В., Егорова А. И., Рентгеновская оптика, М., 1991.

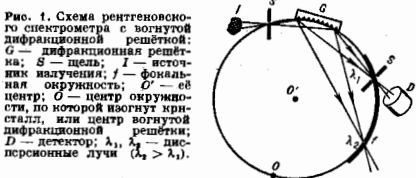
В. В. Аристова, А. И. Егорова, В. А. Селезнев, А. А. Смирнова.
РЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ АППАРАТУРА — аппаратура для рентгеновской спектроскопии и рентгеноспектрального анализа, в к-рой рентг. излучение исследуемого объекта (или рентг. излучение непрерывного спектра, прошедшее через исследуемый объект) разлагается в спектр, регистрируется и анализируется. С помощью Р. с. а., напр., исследуют тонкую структуру рентг. спектров, определяют элементный состав вещества, осуществляют диагностику высокотемпературной плазмы (по рентг. спектрам многозарядных ионов).

Р. с. а. принципиально отличается от оптич. спектральной аппаратуры, т. к. прозрачных для рентг. излучения оптич. материалов не существует и в Р. с. а. не используется линзовая оптика. Отражение рентг. излучения основано на эффекте полного внеш. отражения (см. Рентгеновская оптика), а в дисперсионных системах используется дифракция рентг. лучей. В Р. с. а. диспергирующие и фокусирующие элементы объединены. Для рентг. излучения с длиной волны $\lambda < 2 \text{ \AA}$ вся оптич. часть Р. с. а. должна быть помещена в вакуум, высокая энергия квантов рентг. излучения ($10^3\text{--}10^5 \text{ эВ}$) позволяет проводить его регистрацию в счётном режиме.

Р. с. а. классифицируют по способу разложения излучения в спектр, типу рентг. источника и способу регистрации излучения. В дисперсионной Р. с. а. для разложения излучения в спектр используют дифракц. решётки и кристаллы-анализаторы, в недисперсионной — узкий угол участка спектра выделяют сцинтилляц. счётчиком или пропорциональным счётчиком и полупроводниковым детектором с амплитудным анализатором импульсов. Источниками рентг. излучения могут служить высокотемпературная плазма, синхротроны, рентг. трубки, причём с помощью Р. с. а. исследуют как спектры испускания (флуоресцентные спектры), так и спектры поглощения (абсорбционные). По способу регистрации излучения Р. с. а. разделяют на спектрографы с фоторегистрацией (применяются в осн. в рентг. спектроско-

пии) и спектрометры с регистрирующей детекторами рентг. квантов. По области спектра Р. с. а. делится на коротковолновую (с длиной волны $\lambda \sim 0,1 \div 2 \text{ \AA}$), длинноволновую ($\lambda \sim 2 \div 20 \text{ \AA}$) и ультрдлинноволновую ($\lambda \sim 20\text{--}100 \text{ \AA}$) аппаратуру.

В дисперсионной Р. с. а. в ультрдлинноволновой области спектра излучение разлагают в спектр с помощью вогнутых дифракц. решёток скользящего падения (рис. 1). Разрешение спектрометров с дифракц. решёт-



кой, как правило, ограничивается шириной входной щели и равно

$$\lambda/\Delta\lambda = 0,92R\lambda m/Sd,$$

где S — ширина щели, d — период решётки, m — порядок дифракции, R — радиус решётки.

В области спектра с $\lambda < 20 \text{ \AA}$ излучение разлагают в спектр с помощью кристаллов-анализаторов (табл.),

Кристаллы-анализаторы и их характеристики

Кристалл	Отражающая плоскость	Межплоскостное расстояние, 2d, \AA	Максимальная разрешающая способность, \lambda/\Delta\lambda	Интегральный коэффициент отражения, 10 ⁻⁴ , рад
Карб	001	27,714	1400	8+18
Слюда (уголь)	002	19,884	~2000	2+3
Гипс	020	15,168	—	—
ADP	101	10,658	1000	1+10
EDDT	020	8,808	—	—
PET	002	8,726	8000	10+20
Кварц	1010	8,512	2000	1+10
Кварц	1011	6,7153	1000	2+14
Графит	002	6,698	~100	50+200
Ge	114	6,327	6000	—
Флюорит	111	6,28	—	—
Si	114	6,271	1000	2+10
Кальцит	211	6,089	1500	2+30
NaCl	200	5,84	—	—
Кварц	1120	4,912	3000	0,4+3,3
Топаз	200	4,638	—	—
Кварц	2020	4,246	—	—
LiF	200	4,028	~2000	~10
Ge	220	4,00	1300	17+23
Si	220	3,839	2900	1+8
Кальцит	422	3,034	6400	0,4+0,9
LiF	220	2,848	~1300	10+20
Кварц	2023	2,806	9000	0,3+0,9
Топаз	303	2,712	—	—
Кварц	2240	2,451	—	—
Кварц	2243	2,024	14400	0,2+0,45
Кальцит	633	2,02	12200	0,3+0,6

в них происходит дифракция рентгеновских лучей на атомной структуре. В случае более ДВ-излучения дифракция происходит при отражении излучения от поверхности кристалла, в случае КВ-излучения — при его прохождении через кристалл. В первом случае отражающие атомные плоскости должны быть расположены вдоль, во втором — перпендикулярно поверхности кристалла. В Р. с. а. используются плоские (рис. 2), выпуклые (рис. 3) и вогнутые кристаллы-ана-

Рис. 2. Схема рентгеновского спектрометра с плоским кристаллом: K — кристалл-анализатор (остальные обозначения см. на рис. 1).

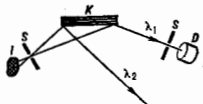


Рис. 3. Схема рентгеновского спектрометра с выпуклыми кристаллом (обозначения на рис. 3 — те же, что на рис. 1 и 2).

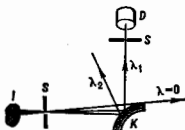
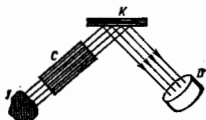


Рис. 4. Схема рентгеновского спектрометра с плоским кристаллом и коллиматором Соллера (C).



лизаторы. Схемы с выпуклыми и плоскими кристаллами позволяют исследовать излучение в широком диапазоне спектра, но являются дефокусирующими. Для повышения светосилы и спектрометрах с плоским кристаллом служат многопластинчатый коллиматор Соллера (рис. 4), ограничивающий угл. расходимость падающего на кристалл излучения от 1° до неск. угл. минут. В фокусирующей Р. с. а. применяются вогнутые кристаллы с цилиндрич. и сферич. поверхностями. В методах Иоганна (рис. 5), Кошуа (рис. 6) и Дю-Монда

Рис. 7. Схема спектрометра Дю-Монда.

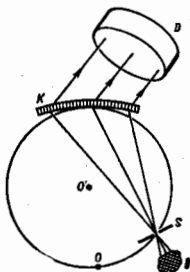
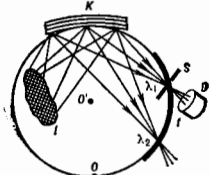


Рис. 8. Схема спектрометра Иогансона.



сцинтилляционные детекторы, полупроводниковые детекторы и др. (см. Детекторы част. п.). Выбор детектора зависит от характера решаемой задачи, спектраль-

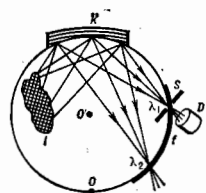


Рис. 5. Схема спектрометра Иоганна.

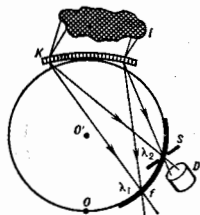


Рис. 6. Схема спектрометра Кошуа.

(рис. 7) плоская кристаллич. пластинка изгибается по цилиндру. поверхности радиуса R , а щель располагается на фокальной окружности радиуса $r = R/2$; эти методы дают довольно острую (но не строго точную) фокусировку спектральных линий. В методе Иоганссона (рис. 8) после предварит. изгиба пластинки кристалла по радиусу R её шлифуют, доводя до цилиндрич. поверхности радиуса $r = R/2$, что обеспечивает точную фокусировку спектра на фокальную окружность. В методе Гамаша (рис. 9) применяются цилиндрически изогнутые кристаллы, а щель и плоскость регистрации располагаются на оси цилиндрич. поверхности. Фокусировка в этом случае осуществляется в направлении, перпендикулярном направлению дисперсии. Спектральное разрешение в кристаллич. спектрометрах ограничивается разрешением выбранного кристалла-анализатора.

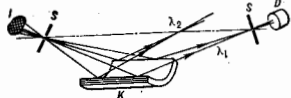


Рис. 9. Схема спектрометра Гамаша.

ного диапазона, требований к чувствительности, пространственному или временному разрешению и др. причин.

Недисперсионная Р. с. а. основана на особенностях поглощения рентг. лучей в веществе и работы нек-рых детекторов рентг. излучения. В ультрадлинноволновой области спектра монохроматизация излучения ($\lambda/\Delta\lambda \sim 10$) обеспечивается сочетанием тонких поглощающих фильтров из разл. материалов и зеркал скользящего падения, а также с помощью многослойных интерференц. зеркал. В ДВ- и КВ- областях для выделения сравнительно узких участков спектра применяются неск. пар балансиров. фильтров с одинаковым коэф. пропускания во всей области спектра, за исключением узкой области между краями поглощения элементов, из к-рых сделаны фильтры каждой пары. Фотометры с такими фильтрами и радиоактивным изотопом в качестве источника первичного излучения служат для флуоресцентного и абсорбционного рентг. излучения (сцинтилляц. и иониз. счётчики, полупроводниковые детекторы); возможен такой режим работы, когда амплитуда регистрируемого импульса пропорц. энергии рентг. кванта. С использованием амплитудного анализатора импульсов детектора можно проводить измерения интенсивности излучения в зависимости от энергии квантов ϵ . Такие детекторы регистрируют ве-

посредственно рентг. излучение и могут работать в качестве спектрометров, характеризующихся очень высокой светосилой, но сравнительно небольшим спектральным разрешением (для пропорц. счётчика $\Delta\lambda/\lambda \approx 10^{-2}$, для полупроводникового детектора $\Delta\lambda/\lambda \approx 10^{-3}$); они применяются в рентгеновском спектральном анализе.

Рентгеновские спектрометры, выпускаемые промышленностью и предназначенные для рентгеновского спектрального анализа, разделяются на простые (одноканальные), регистрирующие узкий участок спектра, в к-ром находится аналитич. линия определ. элемента, двухканальные и многоканальные (квантометры). Т. в. микроанализаторы позволяют производить локальный спектральный анализ; в них обеспечена возможность либо непрерывного изменения частоты излучения, направленного в определ. точку образца, либо сканирования излучения определ. частоты вдоль одного пространственного направления образца. Возбуждение первичного рентг. излучения образца в микроанализаторах осуществляется электронным пучком (зондом) диаметром ок. 1 мкм, а разложение излучения в спектр — светосильными спектрометрами с вогнутыми кристаллами или вогнутыми дифракц. решётками, а также бескристалльными спектрометрами с полупроходными детекторами рентг. излучения. Анализ регистрируемого излучения (рентгеноспектральный электронно-зондовый микроанализ) позволяет получать увеличенное изображение сканируемой поверхности в рентг. излучении определ. элемента и даёт возможность с достаточной высокой точностью получать данные об элементном составе объектов с чувствительностью ок. 10^{-15} г.

Лит.: Блохин М. А., Методы рентгено-спектральных исследований, М., 1959; Плотников Р. И., Пшенничников И. Г. А., Флюоресцентный рентгеноаналитический анализ, М., 1973; Рид С. Д. и В. Б., Электронно-зондовый микроанализ, пер. с англ., М., 1979; Рентгенотехника, Справочник, кн. 1—2, М., 1980; Лосев Н. Ф., Смагунова А. Н., Основы рентгеноцентрального флуоресцентного анализа, М., 1982; Рентгеновский спектроанализ многоканальных каналов, М., 1982; Рентгенофлуоресцентный анализ, под ред. Н. Ф. Лосева, Новосибирск, 1991. А. П. Шевелько.

РЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — см. *Спектроскопия рентгеновская*.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ — метод последней стадии исследования структуры неоднородных объектов в рентг. излучении, основанный на зависимости линейного коэф. поглощения μ в рентг. диапазоне от состава и плотности вещества; один из методов вычислит. томографии.

Классич. схема этого метода, впервые предложенная в медицинской рентгенографии для повышения контраста теневых изображений внутр. органов, приведена на рис. 1. При фиксиров. положении источника излучения S на фотоплёнке образуется теневое изображение, являющееся суммой проекций всех слоёв объекта O , через к-рые проходит пучок. Если в процессе съёмки синхронно перемещать источник и фотоплёнку (или источник и объект, объект и фотоплёнку) так, чтобы пучок проходил в процессе экспозиции только через один и тот же участок объекта в слое F , то изображение I этого участка получится наоб. чётким, изображением др. участков окажутся «размазанными». Этот метод не позволяет полностью избавиться от положения проекций др. участков на исследуемый; кроме того, длительность экспонирования, повышающая контраст, для живых организмов ограничена допустимыми дозами облучения.

Рис. 1. Классическая схема рентгеновской томографии.

В основе совр. методов Р. т. лежит др. подход: они базируются на применении мощных вычислит. методов обработки данных, получаемых томографич. сканированием, один из вариантов к-рого приведён на рис. 2. Узкий пучок рентг. излучения от источника S , сфокусированный коллиматором K , просвечивает объект O ,

после чего регистрируется детектором D . При синхронном перемещении источника и детектора вдоль нек-рого направления x осуществляется последоват. сканирование всех участков объекта, причём связь зарегистрированной детектором интенсивности излучения I с линейным коэф. поглощения μ среды объекта имеет вид интегрального ур-ния:

$$I(x) = I_0 \exp \left[- \int_l \mu(x, l) dl \right],$$

где I_0 — интенсивность падающего пучка, dl — элемент пути поглощения вдоль луча l , соответствующего направлению сканирования. Измерения повторяются для неск. направлений сканирования относительно объекта. Для ускорения съёмки применяют неск. источников или перемещающийся источник с расходящимся «всеребрим» пучком, распределение интенсивности в к-ром измеряется двумерным координатно-чувствительным детектором (рис. 3). Для восстановления распределения μ , а следовательно, плотности и

Рис. 3. Схема рентгеновского томографа с несколькими источниками (S_1, S_2, S_3) и координатно-чувствительным детектором (КЧД).

состава вещества по объёму объекта используют спец. алгоритмы обработки данных на ЭВМ. Синтезируют далее картину распределения плотности тканей объекта в разл. сечениях, можно установить границы злокачественных и нормальных участков, напр. при исследованиях опухолей мозга, патологии. изменяемых сердца, сосудов, поражениях костной ткани и в др. случаях, когда прямая диагностика затруднена или вообще невозможна.

Методы Р. т. используются также в технике неразрушающей дефектоскопии конструкции, материалов, электр. кабелей, механики, узлов, испытывающих большие нагрузки (напр., лопаток турбин авиац. двигателей),

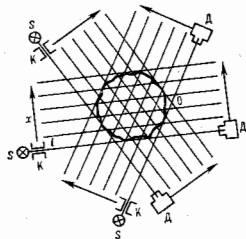
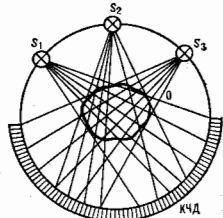


Рис. 2. Схема сканирующего томографа.



и в др. случаях, когда важна точная информация о неоднородностях в объеме тела.

Дитт, Л. и Г. Г., Вишняков Г. Н., Оптическая томография, М., 1989; Физика визуализации изображений в медицине, под ред. С. Уэбба, пер. с англ., т. 1—2, М., 1991.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОПОГРАФИЯ — совокупность методов получения изображений дефектов в кристаллах при помощи дифракции рентг. лучей. Во всех методах Р. т. рентг. пучок от источника направляют на кристалл так, чтобы для всего кристалла или его части выполнялось *Брегга — Вульфа условие*; возникающие при этом дифрагиров. пучки (иногда и прошедший пучок) регистрируются фотопластинкой; фиксируются, изображаясь ваз. рентг. топограммой.

Процесс дифракции рентг. волны в искаженном дефектами кристалле рассматривается в разл. приближениях кинематич. и динамич. теорий (см. *Дифракция рентгеновских лучей*). В обоих случаях влияние искажений атомной структуры на дифракцию описывается параметром локального отклонения положения атомных плоскостей кристалла от брэгговского: $\text{ctg}\theta \cdot \delta d/d + \delta\theta$, где θ — угол Брегга, первое слагаемое учитывает локальное изменение δd межплоскостного расстояния d для отражающих атомных плоскостей, второе — их локальный угол поворота $\delta\theta$. Интенсивность дифрагированного и прошедшего пучков на поверхности выхода из кристалла определяется значениями этого параметра в объеме кристалла, где происходит дифракция рентг. волн. Т. о., распределение интенсивности регистрируемых пучков отображает отклонения строения кристаллич. структуры от идеальной, т. е. рентг. топограмма содержит информацию об искажениях структуры (дефектах). В зависимости от применяемого метода съёмки на топограмме видны границы блоков, единичные дислокации, включения, дефекты упаковки, магн. домены, неоднородности распределения примеси, границы окисных плёнок на поверхностях кристаллов и изделий на них, а также искажения, вызванные внеш. полями (напр., температурными, акустическими и т. п.). Анализ дифрак. контраста (распределения интенсивности) изображений дефектов проводится на основе динамич. теории рассеяния рентг. лучей и позволяет определять некоторые качественные (знак избыточного объёма включений, направление вектора Бюргерса *дислокации*), а в некоторых случаях и количественные характеристики дефектов (величину деформации, величину вектора Бюргерса *дислокаций* и пр.).

Как правило, в Р. т. используется только двухволновая дифракция, когда для каждого пучка излучения с длиной волны λ условие Брегга — Вульфа выполняется только для одной системы отражающих плоскостей и возникает только один дифрагиров. пучок. В соответствии с ф-лой Брегга расходимость дифрагиров. пучка $\delta\theta_d$ в плоскости рассеяния связана с его спектральной шириной $\delta\lambda_d$ соотношением

$$\delta\theta_d = \text{tg}\theta \cdot \delta\lambda_d/\lambda. \quad (1)$$

Если расходимость падающего на кристалл пучка велика, т. е.

$$\delta\theta_1 > \text{tg}\theta \cdot \frac{\delta\lambda_1}{\lambda} \quad (2)$$

($\delta\lambda_1$ — спектральная ширина падающего на кристалл пучка), то $\delta\theta_d$ лимитируется спектральной шириной падающего на кристалл излучения в соответствии с соотношением (1); обычно этот случай реализуется при съёмке в монохроматическом (напр., характеристическом) излучении. Расходимость падающей волны определяется как

$$\delta\theta_1 = \delta x/l,$$

где δx — размер источника в плоскости рассеяния, l — расстояние от источника до кристалла. Напр., при

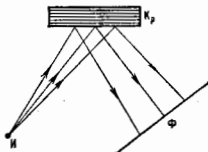


Рис. 1. Схема съёмки рентгеновских топограмм по методу Шулца для исследования блочных кристаллов Кр; И — точечный источник испускающего спектра. Повороты блоков приводят к смешению их изображений на фотопластинке Ф.

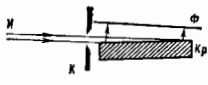


Рис. 2. Схема съёмки топограмм по методу Берга — Баррета для наблюдения дефектов в тонких приращенных монохроматическом излучении; К — коллиматор; Кр — кристалл; излучение падает на кристалл под скользким углом (1—5°).

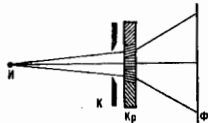


Рис. 3. Схема съёмки топограмм по методу Фудиняра для наблюдения блочности монохроматизованного излучения; И — микрофокусный источник излучения непрерывного спектра; К — коллиматор; съёмка производится при одностороннем отражении излучения от разных семейств атомных плоскостей кристалла Кр. Схема Фудиняра аналогична схеме съёмки лазерами, но в ней используется сильно расходящийся пучок, изучается распределение интенсивности излучения в наклонном дифракционном плите.

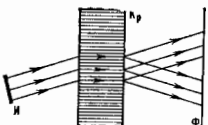


Рис. 4. Схема съёмки топограмм по методу Бормана. В результате эффекта Бормана при выполнении условия Брегга — Вульфа коэффициент поглощения идеального кристалла Кр уменьшается на два порядка. Дефекты, для которых не выполняется условие Брегга — Вульфа, поглощают излучение источника И, что приводит к их изображению на фотопластинке Ф.

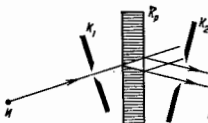


Рис. 5. Схема съёмки топограмм по методу Ланга для наблюдения дефектов в высокоориентированных полупроводниковых монокристаллах. Используется характеристическое излучение $K_{\alpha 1}$ от микрофокусного источника И, которое коллимируется коллиматором K_1 так, чтобы условие Брегга — Вульфа выполнялось для излучения $K_{\alpha 2}$ и не выполнялось для излучения $K_{\alpha 1}$. Фотоплёнку Ф спарывают синхронно с кристаллом Кр для получения изображения дефектов по всей длине кристалла.

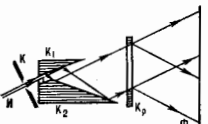


Рис. 6. Схема метода плоской пластины для наблюдения дефектов с особо слабыми волнами искажений (от микродефектов — кластеров, дислокационных микропетель размером 1 мкм и т. д.). Отражение от кристаллов K_1 и K_2 используется для получения высокой коллимации пучка с расходимостью (0,1—0,017°) монохроматического излучения. Кристалл Кр удерживают в определённом отражающем положении в течение десятков часов.

сьёмке в излучении непрерывного спектра и при использовании микрофокусного источника часто справедливо обратное соотношение

$$\delta\theta_1 < \lg \theta \cdot \frac{\delta\lambda}{\lambda}. \quad (3)$$

В этом случае $\delta\theta_1 = \delta\theta_1$, а $\delta\lambda_d$ дается соотношением (1).

Пространственное разрешение на топограмме в плоскости рассеяния определяется геом. и дифракц. уширениями. Геом. уширение $\delta x_G = \delta\theta_d \cdot l_1$, где l_1 — расстояние от кристалла до фотопластины, $\delta\theta_d$ определяется по ф-ле (2) или (3). Дифракц. уширение описывается двумя теориями дифракции рентг. лучей и может быть оценено как $\lambda/g\theta$, где $\lambda = \lambda \cos\theta / \chi_{hkl} \cdot C$ — длина экстинкции, χ_{hkl} — фурье-компонента поляризованности рентгеновской, соответствующая атомным плос-

костям с индексами Миллера (hkl) и коэф. $C = \cos 2\theta$ или 1 (для поляризации в плоскости рассеяния и в перпендикулярной ей плоскости соответственно).

Разрешение в направлении, перпендикулярном плоскости рассеяния, определяется геом. уширением, к-рое может быть уменьшено путём оптимизации схемы съёмки. Принципиальный предел разрешения Р. т. обуславливает дифракц. уширение. Разрешение лимитируется также разрешающей способностью фотопластинок, к-рая не превышает обычно 300—500 линий/мм. Суммарное действие всех факторов на практике позволяет получать на рентг. топограммах изображение с разрешением $\sim 3-5$ мкм.

Все методы Р. т. дают изображение в масштабе, равном или близком 1:1, увеличенное изображение получают оптич. увеличением топограмм. Методы Р. т. применимы для исследования почти совершенных кристаллов,

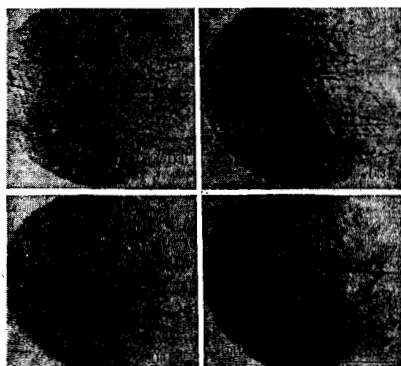


Рис. 7. Топограммы монокристалла Si, полученные с помощью синхротронного излучения. Толщина кристалла 0,35 мм, энергия электронов 7,2 ГэВ, ток в кольце 7 мА, время экспозиции 40 с.



Рис. 8. Топограмма монокристалла Si, полученная методом Лапта. Тонкие чёрные линии — единичные дислокации, тёмные участки — скопления дислокаций, параллельные полосы вдоль краёв кристаллов — экстинкционные контуры или полосы равной толщины.

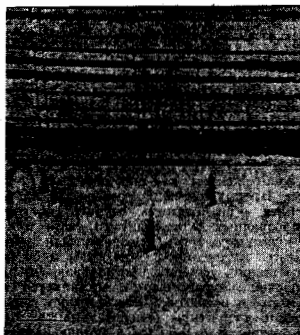


Рис. 9. Топограммы одного и того же кристалла Si, снятые по методу Лапта в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Отражение (220), излучение $\text{Cu K}\alpha_1$, время экспозиции каждой топограммы 5 ч: а — отражающая поверхность с индексами Миллера (110), тонкие вертикальные чёрные линии — дислокации, горизонтальные полосы — слои с неоднородно распределённой примесью, возникшие вследствие колебаний концентрации примеси в расплаве за фронтом кристаллизации при выражении кристалла (полосы роста); б — отражающая поверхность с индексами Миллера (001), изображения тех же дислокаций, что и на рис. а, но ориентированных вдоль распространения пучка.

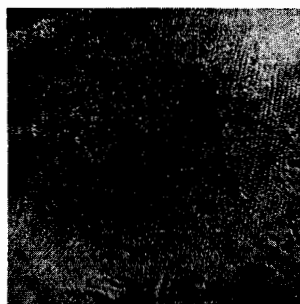


Рис. 10. Изображение магнитных доменов монокристалла иезодитричного граната на рентгеновской топограмме, снятой по методу Лапта. Толщина кристалла 180 мкм, излучение $\text{Ag K}\alpha_1$, отражение (800), время экспозиции 60 ч.



Рис. 11. Топограмма фрагмента интегральной микросхемы на монокристалла Si.

т. е. кристаллов с относительно низкой плотностью дефектов. Допустимая плотность дефектов зависит от применяемой схемы съёмки (рис. 1—6) и лимитируется разрешением; напр., для съёмки по методу Ланга (рис. 5) плотность дислокаций не должна превышать 10^4 см^{-2} . На рис. 7—11 приведены примеры рентг. топограмм с изображением нек-рых дефектов кристаллич. структуры. Преимущество Р. т. перед обычной оптич. микроскопией — возможность изучать дефекты структуры неповерхных для видимого света кристаллов, высокая чувствительность, позволяющая регистрировать отсчет. изменения δd (до 10^{-8}) и $\delta \theta$ (до $0,1^\circ$). Р. т. существенно уступает просвечивающей электронной микроскопии в разрешении, но является неразрушающим методом исследования и контроля и применима для изучения структуры относительно толстых кристаллов — толщиной от $\sim 1 \text{ мкм}$ в методе Ланга до неск. см в методе Бормана, основанном на *аномальном пропускании* эффекте. Осн. область применения Р. т. — исследование и контроль качества высококачественных монокристаллов полупроводников и изделий из них. Недостатки Р. т. — относительно низкое разрешение, большая продолжительность съёмки (от неск. до десятков часов). Для сокращения съёмки применяются мощные источники рентг. излучения — аппараты с вращающимся анодом и синхротроны, для регистрации — системы визуализации рентг. изображений, в частности рентгеноопт. преобразователи-усилители яркости и рентгенотелевиз. системы, позволяющие проводить наблюдения в режиме реального времени.

Лит.: Berg W., History of load of deformed crystals, «Z. Kristallogr.», 1934, № 8/4, p. 286; Ваттсelli C. S., New microscopy and its potentiality, «Trans. Amer. Inst. Min. and Metal. Eng.», 1945, v. 161, p. 15; Schultz L. G., Method of using a fine focus X-ray tube — for examining the surface of single crystals, там же, 1954, v. 200, p. 1082; Вогтманн G., Hillier G. и Hillier G., Röntgen-Wellenfelder in grossen Einkristallen und die Wirkung einer Deformation, «Z. Naturf.», 1956, Bd 112, H. 7, S. 885; Вонсе U., Zur röntgenographischen Bestimmung des Typus einzelner Versetzungen in Einkristallen, «Z. Physik.», 1958, Bd 153, H. 3, S. 278; Ланга А. В., The projection topograph: a new method in X-ray diffraction microradiography, «Acta Crystallogr.», 1959, v. 12, p. 249; Fujii W. и T. N., New method to taking X-ray radiographs the divergent X-ray method, «Mem. Defense Academy», 1963, v. 2, № 5, p. 127; Ивичев В. И., Чуховский Ф. Н., Проблема изображения в рентгеновской оптике, «УФН», 1972, т. 107, в. 2, с. 229; Кауля Д., Физика дифракции, пер. с англ., М., 1979; Computer controlled X-ray topographic imaging system, «The Ricardu Journal», 1984, v. 1, № 1, p. 23; Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении, пер. с англ., М., 1984; Игудал В. Н., Гваридола А. А., Опыт применения рентгеновской топографической установки для наблюдения изображений дефектов кристаллов в условиях аномального прохождения рентгеновских лучей, «Докл. лаборатория», 1987, т. 53, № 3, с. 60.

В. И. Кучинер, Э. В. Суворов.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА — источник рентгеновского излучения, возникающего при бомбардировке

вещества анода (антикатада) электронами, эмитируемыми катодом (электронноаккумуляторной трубки). В Р. т. электроны ускоряются электрич. полем, часть их энергии переходит в энергию рентг. излучения. Излучение Р. т. является *тормозным излучением* в рентг. диапазоне длин волн, при достаточных энергиях электронов на него накладываются характеристикич. излучение вещества анода. Р. т. применяют в рентг. структурном анализе, *рентгеноспектральном анализе*, дефектоскопии, рентгенографии и рентгенодиагностике и т. д. В зависимости от области использования Р. т. различают по типу конструкции, способу получения пучка электронов и его фокусировки, вакуумированию, охлаждению анода, размерам и форме фокуса (области излучения на поверхности анода) и др. Наиб. широко применяются т. в. отпаянные Р. т. с термомиссионным катодом, водяным охлаждением анода, электростатич. фокусировкой электронов (рис.). Термомиссионный катод Р. т. обычно

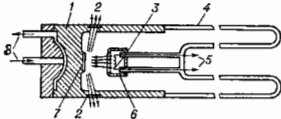


Схема рентгеновской трубки для структурного анализа: 1 — металлический анодный стержень (обычно заземляется); 2 — осяна из бериллия для выхода рентгеновского излучения; 3 — термомиссионный катод; 4 — стержневая обмотка; 5 — вакуумный катод, и которым подводится напряжение накала, а также высоко (относительно анода) напряжение; 6 — электростатическая система фокусировки электронов; 7 — анод; 8 — патрубков для охлаждающей системы.

представляет собой спираль или прямую вольфрамовую нить, накаляемую электрич. током. Рабочий участок анода — металлич. зеркальная поверхность — расположен перпендикулярно или под нек-рым углом к электронному пучку. Для получения сплошного тормозного спектра рентг. излучения высоких энергий в интенсивностей служат аноды на Au или W; в структурном анализе используются Р. т. с анодами из Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Mo, Ag. Осн. характеристики Р. т. — предельно допустимое ускоряющее напряжение (1—500 кВ), электронный ток (0,01 мА — 1 А), уд. мощность, рассеиваемая анодом (10 — 10^4 Вт/мм^2), общая потребляемая мощность (0,002 Вт — 60 кВт). Пд Р. т. составляет 0,1—3%.

РЕНТГЕНОВСКИЕ ПУЛЬСАРЫ — источники переменного периодич. рентг. излучения, представляющие собой вращающиеся *нейтронные звезды* с сильным магн. полем, излучающие за счёт аккреции. Магн. поля на поверхности Р. п. $\sim 10^{11}$ — 10^{14} Гс. Соемности большинства Р. п. от 10^{30} до 10^{38} эрг/с. Периоды следования импульсов Р. п. от 0,07 с до неск. тыс. секунд. Р. п. входят в тесные двойные звездные системы (см. *Тесные двойные звезды*), вторым компонентом к-рых является нормальная (невыврожденная) звезда, поставляющая вещество, необходимое для аккреции и нормального функционирования Р. п. Если второй компонент находится на стадии эволюции, когда скорость потери массы мала, нейтронная звезда не проявляет себя как Р. п. Рентг. пульсары встречаются как в массивных молодых двойных звездных системах, относящихся к населению I Галактики и лежащих в её плоскости, так и в маломассивных двойных системах, относящихся к населению II Галактики и принадлежащих к её сферич. составляющей. Р. п. открыты также в Магеллановых Облаках. Всего открыто ок. 30 Р. п.

На нач. этапе исследований рентг. объектам присваивались наименования по созвездиям, в к-рых они находились. Напр., Геркулес X-1 означает первый по кат. яркости объект в созвездии Геркулеса, Кентавр

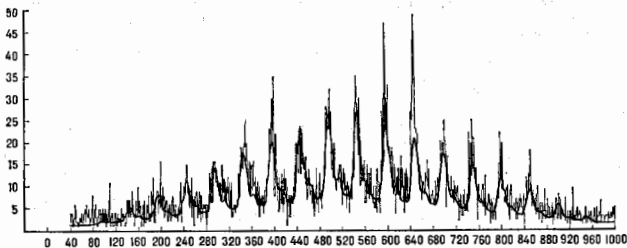


Рис. 1. Запись излучения рентгеновского пульсара Кентавр X-3, полученная со спутника «Ухуру» 7 мая 1971 г. По вертикальной оси — число отсчетов за временной интервал t (мс) — 0,096 с, по горизонтальной — время в бинах. Регистрируемый поток максимален, когда источник находится в центре поля зрения счётчика, ограниченного коллиматором. Из-за вращения спутника регистрируемый средний поток сначала нарастает, а затем падает. На эту простую зависимость от времени наложены периодические пульсации, связанные с собственной неровностью источника.

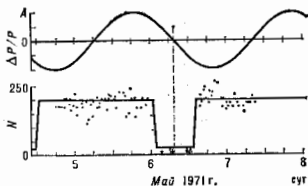


Рис. 2. Долгопериодическая неровность рентгеновского излучения источника Кентавр X-3 (нижний график). N — число отсчетов, c^{-1} . Видны характерные рентгеновские затмения. На верхнем графике приведены изменения периода P , допускающие движение пульсара вокруг центра масс двойной системы ($A \approx 1,387 \cdot 10^{-4}$).

X-3 — третий по яркости в созвездии Кентавра. Р. п. в Малом Магеллановом Облаке обозначается как SMC X-1, в Большом Магеллановом Облаке — LMC X-4 [часто встречающаяся в обозначениях рентг. источников буква X — от англ. X-rays (рентг. лучи)]. Обнаружение со спутников большого числа рентг. источников потребовало др. системы обозначений. Напр., 4U 1900-40 соответствует обозначению Р. п. Паруса X-1 в четвертом каталоге спутника «Ухуру» (СИА). Первые четыре цифры обозначают прямое восхождение (19 ч 00 мин), вторые две вместе со знаком дают склонение объекта (см. *Координаты астрономические*). Апологичный смысл имеют цифры в обозначении источников, открытых спутником «Ариэль» (Великобритания), напр. A0535 + 26. Обозначения типа GX1+4 относятся к источникам в центр. области Галактики. Цифры соответствуют галактик. координатам l и b (в данном случае $l = 4^\circ$, $b = +4^\circ$). Употребляются и др. обозначения. Так, открытый с борта советских АМС «Венера-11, -12» в эксперименте «Конус» вспыхивающий Р. п. с периодом около 8 секунд получил наименование FX P0520-66.

Периодичность излучения рентгеновских пульсаров. Короткопериодич. периодичность рентг. излучения Р. п. иллюстрирует рис. 1, на к-ром приведена запись излучения одного из первых открытых Р. п. — Кентавра X-3 (май 1971, спутник «Ухуру»). Период следования импульсов $P = 4,8$ с.

На рис. 2 показана долгопериодич. периодичность Р. п. Кентавр X-3. Раз в две суток Р. п. периодически «исчезает» (затмевается) на 11 ч (ниж. график). Тщательные исследования показали также, что P зависит

от фаз двухдневного периода $T = 2,087$ сут по гармонич. закону (верх. график): $\Delta P/P = A \cos[2\pi(t - t_0)/T]$, где $\Delta P = P - P_0$ — изменение P , P_0 — невозмущенное значение P , A — амплитуда относит. изменения P , t_0 соответствует одному из моментов, когда отклонение периода максимально. Эти два факта интерпретируются однозначно: Р. п. входит в двойную систему с орбитальным периодом, равным T . «Исчезновение» объясняется затмениями Р. п. вторым компонентом двойной системы. По продолжительности затмения можно сделать вывод о том, что второй (затмеваящий) компонент затопит свою полость Рошса. Периодич. изменения Р. п. обусловлены эффектом Доплера при орбитальном движении Р. п. вокруг центра масс двойной системы. Амплитуда изменения периода $A = (v/c) \sin i$, где i — угол наклона орбиты двойной системы (в этой системе близок к 90°), v — скорость орбитального движения Р. п.;

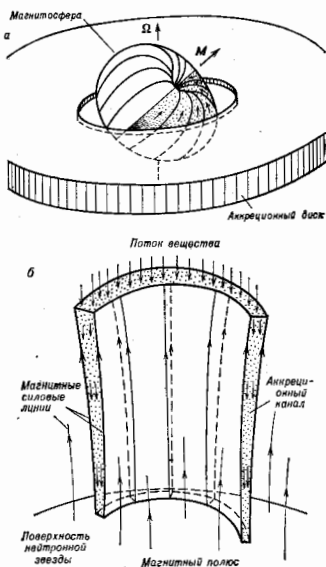


Рис. 3. Упрощенная картина аккреции на замagnetизированную нейтронную звезду в двойной системе. Газ поступает к звезде как в геометрически тонком диске, так и сферически-симметричным образом. Реальная магнитосфера имеет более сложную форму, чем это изображено на рис. а (Ω и M — угловая скорость вращения и магнитный момент нейтронной звезды). Условия вморожения плазмы в магнитосферу благоприятны не на всей ее поверхности. Вмороженная плазма течет вдоль магнитных силовых линий к магнитным полюсам (стрелки). Вблизи полюсов аккреционный канал представляет собой незамкнувший вилет (θ),

$v \sin i = 416$ км/с, эксцентриситет орбиты мал. Рентг. затмения обнаружены далеко не во всех двойных системах с Р. п. (для наблюдения затмений необходимо, чтобы луч зрения был близок к плоскости орбиты двойной системы), а периодич. изменения P — в большинстве двойных систем с Р. п.

После открытия Р. п. в его окрестности обычно быстро находят переменную оптич. звезду (второй компонент двойной системы), блеск к-рой меняется с периодом, равным орбитальному или в два раза меньшим (см. ниже). Кроме того, спектральные линии оптич. компонента испытывают доплеровский сдвиг, периодически изменяющийся с орбитальным периодом двойной системы. Оптич. переменность двойных систем с Р. п. обусловлена двумя эффектами. Первый эффект (эффект отражения) наблюдается в системах, в к-рых светимость оптич. звезды меньше светимости Р. п. Сторона звезды, обращенная к Р. п., прогревается его рентг. излучением и в оптич. лучах оказывается ярче, чем противоположная сторона. Вращение двойной системы приводит к тому, что наблюдается то более яркая, то менее яркая сторона звезды. Такой эффект наиб. отчетливо проявляется в системе, включающей Р. п. Геркулес X-1 и звезду HZ Геркулеса. На единичную поверхность этой звезды, обращенной к рентг. источнику, падает в тридцать раз больше энергии в виде рентг. излучения, чем поступает из недр звезды. В результате амплитуда оптич. переменности превышает 2^m в фильтре B (см. *Астрофотометрия*). Часть рентг. излучения отражается атмосферой звезды, но осн. доля поглощается ею и перера-

батывается в оптич. излучение, к-рое слабо пульсирует с периодом P . Часть энергии уходит на афф. нагревание вещества на поверхности, сопровождающееся формированием т. н. индуциров. *звездного ветра*. Второй эффект, называемый эффектом эллипсоидальности, связан с тем, что форма звезды, заполняющей полость Роша, заметно отличается от сферической. В результате два раза за орбитальный период к наблюдателю обращена б. ч. поверхности и два раза — меньшая. Такая переменность с периодом, вдвое меньшим орбитального периода, наблюдается в двойных системах, где светимость оптич. компонента намного превышает рентг. светимость Р. п. В частности, именно благодаря такой переменности был открыт нормальный компонент источника Кентавр X-3.

Аккреция на нейтронную звезду с сильным магнитным полем. В тесных двойных звездных системах возможны два осн. типа аккреции: дисковая и сферически-симметричная. Если перетекающее вещество идет преим. через внутр. точку Лагранжа (см. в ст. *Полость Роша*), то перетекающее вещество обладает значит. уд. моментом кол-ва движения и вокруг нейтронной звезды образуется аккреционный диск. Если нормальная звезда теряет вещество посредством звездного ветра, то возможны формирование ударной волны и близкая к сферически-симметричной аккреция за ней.

Свободное падение (при сферически-симметричной аккреции) возможно лишь на больших расстояниях R от звезды. На расстояния $R_m \sim 100-1000$ км (радиус

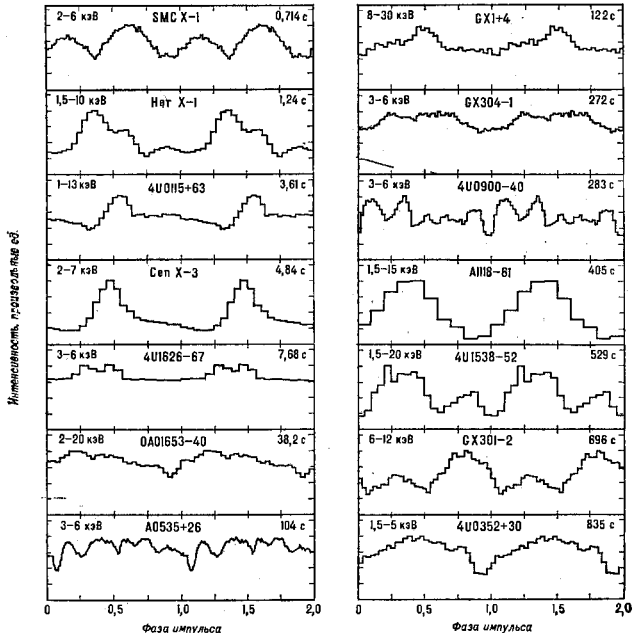


Рис. 4. Профили импульсов ряда рентгеновских пульсаров. Приведены интервалы энергий, для которых получены данные, и периоды P .

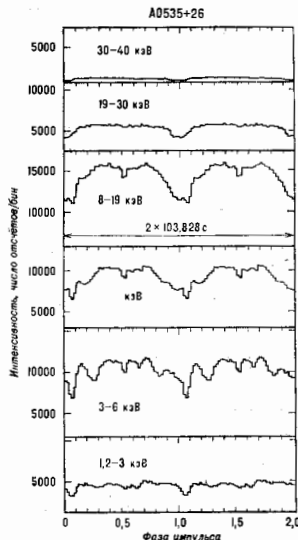
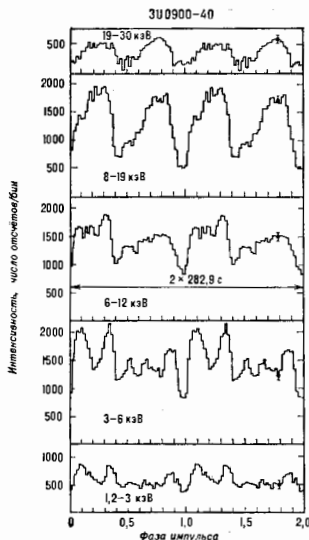


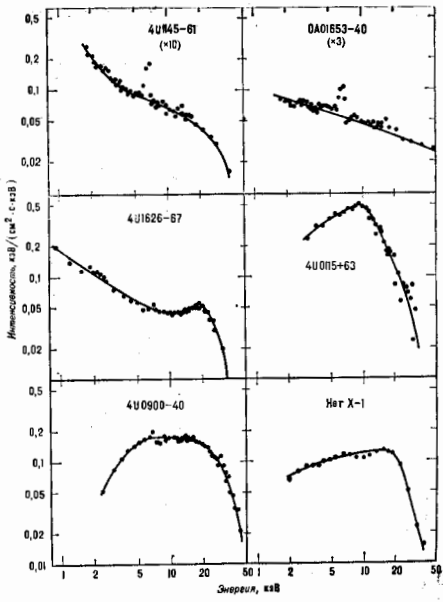
Рис. 5. Зависимость профиля импульсов от энергии для двух рентгеновских пульсаров.

Рис. 6. Спектры ряда рентгеновских пульсаров. Заметна рентгеновская линия железа с $\lambda_{\text{ж}} \approx 6,5 - 7$ кэВ.

магнитосферы) давление магн. поля нейтронной звезды $P^2/8\pi \propto R^{-4}$ сравнивается с давлением аккрецирующего потока вещества $\rho V^2 \propto R^{-3/2}$ (ρ — плотность вещества) и останавливает его. В зоне $R < R_m$ формируется замкнутая магнитосфера нейтронной звезды (рис. 3, а), вблизи R_m возникает ударная волна, в к-рой плазма охлаждается излучением Р. п. за счёт комптоновского рассеяния. Благодаря неустойчивости Рэлея—Тейлора становится возможным проникновение каплей плазмы внутрь магнитосферы, где происходит их дальнейшее дробление и вмораживание в магн. поле. Магн. поле каналирует поток аккрецирующей плазмы и направляет её в область магн. полюсов (рис. 3, б). Зона, на к-рую выпадает вещество, по-видимому, не превышает по площади 1 км^2 . На поверхности нейтронной звезды гравит. энергия связи на единицу массы $\eta \approx 0,15 \text{ с}^2$. Поток выпадающего на звезду вещества, необходимый для поддержания светимости $L_x \sim 10^{38} - 10^{39} \text{ эрг/с}$, равен $\dot{M} \sim L_x/\eta \sim 10^{15} - 10^{16} \text{ г/с} = 10^{-11} - 10^{-12} M_{\odot}$ в год. На 1 см^2 поверхности выпадает более тонны вещества в секунду. Скорость свободного падения составляет $0,4 \text{ с}$.

В Р. п. со светимостью $L_x < 10^{38} \text{ эрг/с}$ падающие протоны и электроны тормозятся в атмосфере (образованной веществом, выпавшим на нейтронную звезду за ничтожные доли секунды до этого) за счёт ядерных и кулоновских столкновений. Выделяющаяся энергия излучается слоем, поверхностная плотность к-рого ок. $10 - 20 \text{ г/см}^2$, а толщина — неск. метров. Существует предположение, что может возникнуть тонкая (неск. см) бесстолкновительная ударная волна, в к-рой выделяется вся кинетич. энергия аккрецирующего потока.

В Р. п. со светимостью, близкой к $5 \cdot 10^{38} \text{ эрг/с}$, колоссальное энерговыделение в зоне магн. полюсов приводит к тому, что сила давления излучения (см. Давление света) на падающие электроны способна остановить поток аккрецирующего вещества. Вблизи поверхнос-



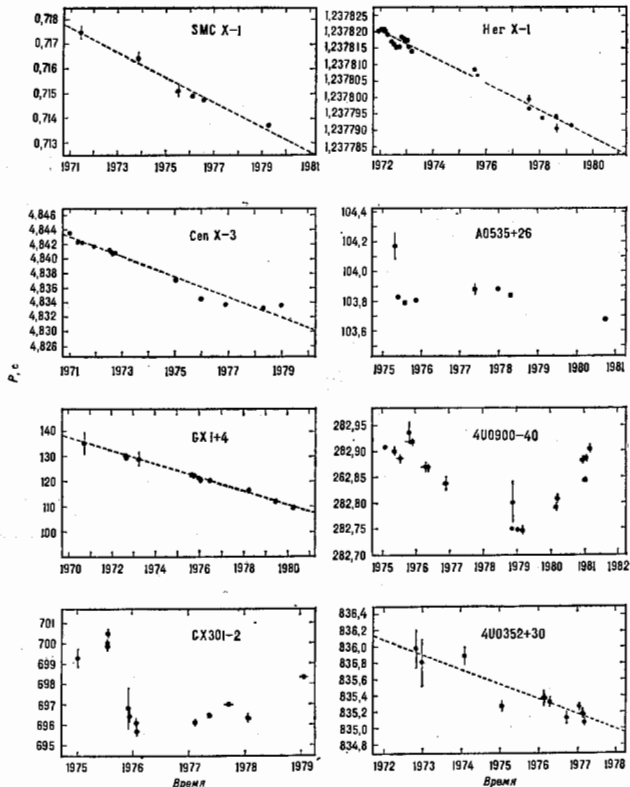


Рис. 7. Зависимость периода P (в с) от времени для ряда рентгеновских пульсаров.

ти нейтронной звезды (на высоте меньше 1 м) может сформироваться радиан.-доминиров. ударная волна. В такой ударной волне давление излучения намного превышает давление плазмы. Падающие на звезду электроны тормозятся силой давления излучения, обусловленной томосовским рассеянием излучения, идущего снизу. Одновременно останавливаются связанные с электронами электростатич. силы протоны, несущие осн. кинетич. энергию. Эта энергия расходуется на увеличение энергии фотонов вследствие их многократных рассеяний на высокоскоростных электронах (комптонизации). Часть «жестких» фотонов уходит к наблюдателю, а часть попадает в плотные слои атмосферы (нейтронной звезды), нагревая её. В этих слоях вследствие тормозного излучения рождаются многочисл. «мягкие» фотоны, к-рые, испытывая томосовское рассеяние на падающих электронах, тормозят падающее вещество.

Если светимость P п. п. превышает 10^{37} эрг/с, то над поверхностью нейтронной звезды в районе магн. полюсов формируется аккреционная колонка. Радиан.

доминиров. ударная волна возникает на большой высоте над поверхностью нейтронной звезды (сотни метров и даже километров). В ней происходит торможение потока. Под ударной волной осуществляется режим оседания. Излучение уходит через боковую поверхность колонки, вещество же в ней медленно оседает, выделяя гравитац. энергию, превращающуюся в тепло и излучение. Силам гравитации противодействует градиент давления излучения, запертого в радиан.-доминиров. колонке. Колонка может обеспечить светимость, намного превышающую критическую светимость, т. к. с боков она удерживается магн. полем, а не силами гравитации. Более того, если магн. поле нейтронной звезды превышает 10^{13} Гс, то в основании колонки темп-ра плазмы и излучения достигает 10^{10} К. При таких темп-рах происходят процессы рождения и аннигиляции электрон-позитронных пар. Нейтрино, образующиеся в реакции $e^+ + e^- \rightarrow \nu + \bar{\nu}$, уносят осн. долю светимости. Рентг. светимость (превышающая критическую) составляет малую долю нейтринной светимости $L_\nu = \eta \dot{M}$, причём

светимости SMC X-1 и LMC X-4 $\sim 10^{39}$ эрг/с, т. е. па-
много превышают критическую. Эти объекты имеют,
по-видимому, и значит, нейтринную светимость. излу-
чаемые нейтрино прогревают недра нейтронной звезды
и, поглощаясь в недрах нормального компонента двой-
ной системы, дают малый вклад в его оптич. светимость.
Поток аккрецирующего вещества в таких объектах мо-
жет достигать $(10^{-4} - 10^{-3}) M_{\odot}$ в год. В этом случае воз-
можна ситуация, когда за $10^6 - 10^8$ лет «работы» Р. п.
на нейтронную звезду выпадает ок. $1 M_{\odot}$ вещества, будет
превышен предел устойчивости для нейтронных звезд,
происойдет *равитационный коллапс*, сопровождаемый
взрывом *сверхновой звезды* редко встречающегося типа
и образованием *чёрной дыры*. Это может происойти лишь
при дисковой аккреции, когда давление излучения не
препятствует аккреции на больших расстояниях от тя-
готеего центра.

**Формирование профилей импульсов и спектры
излучения рентгеновских пульсаров.** Выделение энер-
гии в огранич. зоне вблизи полюсов нейтронной звезды
в совокупности с её вращением приводит к феномену
пульсара: наблюдатель видит излучающую зону под
разными углами и принимает переменный во времени
поток рентг. излучения. Период P равен периоду вра-
щения нейтронной звезды. Наличие сильного магн.
поля может приводить к направленности излучения.
В зависимости от соотношения между энергией фотонов
 $h\nu$, напряжённостью магн. поля H и темп-рой плазмы
 T_e могут формироваться как «крандальная», так и
«ножевая» диаграммы направленности. Важнейший
параметр — гирочастота (циклотронная частота) элект-
ронов $\omega_H = eH/2mc$. Степень направленности является
функцией отношения v/c и kT/vH . Диаграмма направлен-
ности определяет форму профиля импульсов Р. п.
Профили импульсов ряда Р. п. приведены на рис. 4.
Вид профилей у многих Р. п. изменяется с увеличением
энергии фотонов (рис. 5).

Спектр излучения нейтронной звезды должен быть
многокомпонентным. Излучают ударная волна, аккре-
ционная колонка, поверхность нейтронной звезды вблизи
основания колонки, плазма, текущая по магнито-
сфере к полюсам нейтронной звезды. Эта плазма погло-
щает жёсткое излучение колонки и переизлучает его в
«мягком» рентг. диапазоне как в континууме (непрерыв-
ном спектре), так и в рентг. линиях (характеристиче-
ских и резонансных) ионов тяжёлых элементов. Спектры
(рис. 6) решающим образом зависят от светимости
Р. п. и напряжённости магн. поля, поэтому они силь-
во отличаются друг от друга.

Если потоки плазмы на магнитосфере Р. п. высокой
светимости не покрывают всю её поверхность, то обра-
зуются «окна», в к-рых свободно выходит «жёсткое»
излучение, в то время как др. направления для него
закрыты из-за большой оптич. толщи потоков плазмы.
Вращение нейтронной звезды должно приводить к пуль-
сациям излучения. Это ещё один механизм формирова-
ния профиля рентг. импульсов.

Важнейшим этапом в изучении Р. п. является откры-
тие гиролиний [спектральной линии, обусловленной
циклотронным излучением (либо поглощением) элект-
ронов] в спектре Р. п. Геркулес X-1. Открытие ги-
ролиний дало метод прямого эксперим. определения
магн. полей нейтронных звезд. Гиролиния в спектре
Р. п. Геркулес X-1 соответствует $h\nu_H = 56$ кэВ.
Согласно соотношению $h\nu_H = 1,1 (H/10^{11} \text{ Гс})$ кэВ, на-
пряжённость магн. поля на поверхности этой нейтрон-
ной звезды $\approx 5 \cdot 10^{12}$ Гс.

Ускорение и замедление вращения нейтронных звезд.
В отличие от радиопулсаров (сек-рые из них, в част-
ности пульсары в Крабе и Парусас, излучают в рентг.
диапазоне), излучающих за счёт энергии вращения
замедляющейся нейтронной звезды и увеличивающих
свой период со временем, Р. п., излучающих за счёт
аккреции, ускоряют своё вращение. Действительно при
дисковой аккреции вещество, выпадающее на магнито-

сферу, имеет заметный уд. момент кол-ва движения.
Вмороживаясь в магн. поле, аккрецирующая плазма
движется к поверхности звезды и передаёт ей свой мо-
мент кол-ва движения. В результате вращение звезды
ускоряется и период следования импульсов уменьша-
ется. Этот эффект характерен для всех Р. п. (рис. 7).
Однако иногда наблюдается и замедление вращения.
Это возможно в случае, если меняется темп аккреции
либо направление момента кол-ва движения аккреци-
рующего вещества. Среди механизмов, приводящих
к увеличению периода, обсуждается т. н. пропеллерный
механизм. Предполагается, что асимметричная атмо-
сфера нейтронной звезды вращается в атмосфере, соз-
данной аккрецирующим со звуковой скоростью газом,
при этом генерируются звуковые или ударные вол-
ны, возбуждаются конвективные течения, отводящие
момент количества движения от магнитосферы к
звездному ветру, обтекающему нейтронную звезду.

Р. А. Сюняев.

РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРЫ — спектры испускани-
я (эмиссионные Р. с.) и поглощения (абсорбционные
Р. с.) *рентгеновского излучения*. В зависимости от ме-
ханизма возбуждения рентг. излучения, от излуча-
ющей системы Р. с. могут быть непрерывными или ли-
нейчатыми. Линейчатый Р. с. испускают атомы и ионы
после ионизации их внутр. оболочек при последую-
щем заполнении образовавшихся вакансий; такой Р. с. наз.
характеристическим, т. к. однозначно
характеризует излучаемый атом. Непрерывным явля-
ется тормозной Р. с. (см. *Тормозное излучение*),
спектр *синхротронного излучения* или *однудатного
излучения* в рентг. диапазоне. Чаще всего исследуют
Р. с. твёрдых тел, возбуждаемые *рентгеновской тру-
бкой*. Большой интерес представляет изучение Р. с.
многозарядных ионов и плазмы. Для получения и иссле-
дования Р. с. применяют спектрометры 2 типов: спек-
трометры с диспергирующим элементом — кристалло-
анализатором или дифракц. решёткой (т. н. *вольтова
дисперсия*) и спектрометры на основе пропорц. детек-
тора и амплитудного анализатора импульсов (т. н.
энергетич. дисперсия; см. *Рентгеновая спектральная
аппаратура*).

Спектр излучения рентг. трубки — первичного рентг.
излучения — является наложением характеристиче-
ского Р. с. на тормозной. Исследуемое вещество в этом
случае служит анодом трубки. Характеристич. излу-
чение атомов анода возбуждается при ионизации их
внутр. оболочек электронным пучком, тормозное из-
лучение — при торможении электронов в веществе ано-
да. Характеристич. Р. с. получают также при воз-
буждении флуоресценции в рентг. диапазоне вещества
первичным рентг. излучением.

Характеристические рентгеновские спектры состоят
из спектральных серий (K, L, M, N, O), все линии каж-
дой из к-рых объединены общим начальным уровнем
ионизации; уровни энергии, с к-рых происходит кван-
товый переход при заполнении образовавшейся ва-
кансии для линий одной серии различны. Вероятность
излучат. переходов разл. мультиплетности, а следова-
тельно, и интенсивность соответствующих спектраль-
ных линий определяются различными *отбора пра-
вилами*. Переходы для наиб. ярких линий K - и L -серий,
а также обозначения этих линий приведены на рис. 1.
Линии одной серии элементов образуют одинаковые
группы дублетов, что позволило дать им одинаковые
для всех ат. номеров Z обозначения греческими
или латинскими буквами. Зависимость спектрального
нодожения одноимённых линий от Z определяется
Мозли законом.

С возрастанием напряжения V на рентг. трубке
в Р. с. появляются одновременно все линии q -серии,
когда V превышает потенциал V_q возбуждения нижнего
общего для них уровня энергии (q -серия — одна из K -,
 L -, M -, ...серий). С дальнейшим повышением V элект-
роны проникают глубже в анод, всё большее число

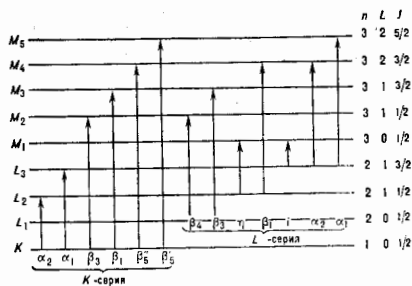


Рис. 1. Схема K-, L- и M-уровней энергии атома и основные линии K- и L-серий; n, l, j — главное, орбитальное и внутреннее квантовые числа уровней энергии K, L_1, L_2 и др.

атомов возбуждается и испускает излучение q-серии; интенсивность I_q линий растёт. Для напряжений $V_0 < V < 3V_0$ интенсивность q-линий $I_q \sim (V - V_0)^2$. С дальнейшим ростом V рентг. излучение частично поглощается атомами анода при выходе из него, рост I_q замедляется. При $V \approx 11V_0$ с дальнейшим повышением V интенсивность I_q уменьшается, т. к. большинство возбуждённых атомов располагается так глубоко в аноде, что их излучение поглощается в нём.

При возбуждении первичным излучением флуоресценции в рентг. диапазоне длин волн (см. Луминесценция) интенсивность линий флуоресценции зависит от энергии $h\omega$ фотонов первичного излучения. Если $\omega < \omega_0$ (где ω_0 — частота порога возбуждения q-серии, то $I_q = 0$. При $\omega = \omega_0$ появляется вся q-серия флуоресцентного излучения, но с дальнейшим возрастанием $\omega > \omega_0$ интенсивность I_q быстро падает. Поэтому для возбуждения флуоресцентного излучения для анода используют вещество, яркие линии характеристич. спектра k-рога расположены со стороны частот $\omega > \omega_0$ и как можно ближе к ω_0 . Для возбуждения флуоресцентного излучения q-серии данного элемента можно также использовать тормозное излучение анода рентг. трубки из атомов элементов с возможно большим Z.

Интенсивность характеристич. спектра (как первичного, так и флуоресцентного) зависит от вероятности p_r излучат. перехода атома с вакансией на q-уровне, k-рая определяется суммарной вероятностью испускания фотонов при заполнении данной вакансии электроном каждого из вышерасположенных уровней. Однако с вероятностью p_A та же вакансия может заполняться электроном безызлучательно в результате *же-эффекта*. Для K-серии средних и тяжёлых элементов $p_r > p_A$ для лёгких элементов $p_r < p_A$. Для остальных серий всех элементов $p_r < p_A$. Отношение $f = p_r / (p_r + p_A)$ наз. выходом характеристич. излучения.

Кроме линий характеристич. излучения, появляющихся после однократной ионизации атома, в спектре обнаруживаются и более слабые линии, возникающие при двукратной (или даже многократной) ионизации атома, когда на разных его оболочках одновременно образуются 2 (или более) вакансии. Если, напр., в атоме образовалась лишь одна вакансия в K-оболочке и она заполняется электроном $L_{2,3}$ -оболочки, то атом испускает дублет $K\alpha_{1,2}$. Если корг вакансии в K-оболочке в атоме образовалась ещё одна вакансия в $L_{2,3}$ -оболочке, к-рая сохраняется при переходе атома на начальное состояние двукратной ионизации $KL_{2,3}$ в конечное состояние также двукратной ионизации $L_{2,3}L_{2,3}$, то атом испускает излучение с энергией, немного превышаю-

щей энергию дублета $K\alpha_{1,2}$; в спектре появляется дублет $K\alpha_{2,1}$, называемый сателлитом оси дублета $K\alpha_{1,2}$. В результате процессов, связанных с начальной двукратной (или многократной) ионизацией атома, в Р. с. появляются многочисл. сателлиты — спутники оси. линий однократной ионизации атома. Интенсивность сателлитов в десятки или сотни раз слабее интенсивности оси. линии, однако при бомбардировке атомов тяжёлыми ионами высокой энергии вероятность многократной ионизации атома превосходит вероятность его однократной ионизации и интенсивность оси. линии оказывается значительно меньше интенсивности сателлитов.

Тормозной рентгеновский спектр. Тормозное излучение рентг. трубки возникает при рассеянии электронов на алектростатич. поле атома. Потери энергии электрона на излучение при этом носит квантовый характер и сопровождается испусканием фотона с энергией $h\nu$, к-рая не может превосходить кинетич. энергию \mathcal{E} электрона: $h\nu \leq \mathcal{E}$. Частота ω_0 , соответствующая равенству $h\nu_0 = \mathcal{E}$, наз. квантовый границей тормозного спектра. Длина волны $\lambda_0 = 2hc/\omega_0$ (также называемая границей тормозного спектра) зависит от напряжения V на рентг. трубке:

$$\lambda_0 = hc/eV = 1,240/V$$

(λ_0 — в нм, V — в кВ). При $\lambda < \lambda_0$ интенсивность тормозного излучения $I_T = 0$. С ростом λ от λ_0 до $\lambda_m = (v_0/v_0)\lambda_0$ интенсивность I_T возрастает, а затем падает, т. к. возрастает поглощение тормозного излучения веществом анода, т. е. возбуждение его K-серии (рис. 2).



Интенсивность I_T скачкообразно возрастает при значении λ , большем значения λ_k (см. ниже). В области больших λ становится существенным поглощение излучения «окном» рентг. трубки (атомами Ве), вследствие чего при $\lambda > 1,5$ нм интенсивность рентг. излучения практически равна нулю. С возрастанием напряжения V на рентг. трубку λ_0 и λ_m сдвигаются в сторону меньших λ .

Спектр поглощения получают, пропуская тормозное излучение рентг. трубки или синхротронное излучение через тонкий поглотитель. При энергиях фотонов $h\nu > \mathcal{E}_K(\mathcal{E}_K$ — энергия ионизации K-уровня атомов поглотителя) из атома в результате фотоэффекта могут быть вырваны электроны с любого из уровней энергии атома, т. е. в процессе поглощения участвуют электроны всех оболочек атома. При $\mathcal{E}_L < h\nu < \mathcal{E}_K$ электроны K-оболочки не вырываются излучением и в процессе поглощения участвуют лишь электроны всех остальных оболочек, начиная с L-оболочки. Поэтому при $h\nu = \mathcal{E}_K$ наблюдается скачок поглощения S_K . В этой точке спектра поглощение резко уменьшается и интенсивность рентг. излучения, прошедшего через поглотитель, скачком возрастает. Скачок поглощения S_K изменяется с ат. номером Z элементов от 35 для самых лёгких элементов до 5 для самых тяжёлых. Аналогичные скачки поглощения наблюдаются и при переходе через энергии \mathcal{E}_q остальных q-уровней атома. Поскольку каждой энергии \mathcal{E}_q соответствует свой скачок поглощения, эти энергии наз. крайним поглощения q-уровней. Каждый край поглощения определяет вместе с тем и квантовую границу возбуж-

дения соответствующей спектральной серии эмиссионного Р. с.

Интенсивность рентг. излучения, прошедшего через поглотитель с поверхностной плотностью m (в г/см²), определяется ф-лой $I = I_0 \exp(-\tau m)$, где I_0 — интенсивность излучения до поглощения, τ — массовый коэф. поглощения (в см²/г). В пределах между двумя соседними краями поглощения τ растёт $\propto \lambda^2$. Зависимость $\tau(\lambda)$ во всем интервале λ представляет спектр поглощения. С коротковолновой стороны от каждого края поглощения величина τ претерпевает флуктуации, к-рые несут информацию о структуре вещества и изучаются методами рентгеновской спектроскопии.

Для осуществления излучат. перехода в атоме после возникновения вакансии на его внутр. оболочке необходимо, чтобы на более удаленной оболочке был хотя бы один электрон. Так, после образования вакансии в К-оболочке фотон линии $K\alpha_{1,2}$ испускается при переходе $L_{2,3} \rightarrow K$. У свободных атомов с возрастанием Z первый электрон в оболочке $L_{2,3}$ появляется только у Z ($Z = 5$). Однако взаимодействие атомов в твердом теле изменяет распределение электронов по оболочкам атома и линия $K\alpha_{1,2}$ наблюдается уже у Li ($Z = 3$).

Особый интерес представляет эмиссионный переход атома при заполнении внутр. вакансии электроном валентной оболочки атома, если она заполнена частично, т. е. когда в ней имеются вакансии. Так, при наличии вакансии на К-уровне, заполняемой электронами с валентного $M_{4,5}$ -уровня, К-электрон в процессе поглощения может быть заброшен на вакансию $M_{4,5}$ -уровня, а один из электронов этого же уровня заполняет К-вакансию, т. е. абсорбционный и эмиссионный переходы взаимно обратны, и энергия поглощаемого фотона равна энергии испускаемого фотона (линия $K\beta_2$). С возрастанием Z оболочка $M_{4,5}$ полностью заполняется и поглощение возможно лишь при забрасывании К-электрона в более удаленную оболочку, где имеются вакансии. Т. о., при возрастании Z атом, у к-рого первые энергии поглощаемого фотона (края поглощения) превысит энергию фотона $K\beta_2$ -линии, имеет заполненную $M_{4,5}$ -оболочку. Если для свободных атомов эта оболочка первые заполняется у Cu ($Z = 29$), то в твердом теле такое заполнение происходит только у Ge ($Z = 32$). Т. о., Р. с. позволяют получить полную картину заполнения электронных оболочек атома в твердых телах при возрастании Z.

Р. с. нашли применение в рентгеноспектральном анализе, в рентг. спектроскопии, рентгеновском структурном анализе, а также при исследовании распределения по уровням энергии электронов в атомах твердого тела.

Лит. см. при ст. Рентгеновое излучение. М. А. Блохин. **РЕНТГЕНОВСКИЕ СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ** — стоячие волны, возникающие в достаточно толстых монокристаллич. пластинах при падении на них эйнштейновского рентг. излучения (с длиной волны $\lambda \sim 5$ —20 нм) под углом Брэгга (при выполнении Брэгга — Вульфа условий) и осуществлении в них динамич. дифракции рентгеновских лучей. Метод Р. с. в — перспективный метод исследования структуры вещества.

Если на кристалл под углом Брэгга падает плоская волна рентг. излучения $E_0 \exp(i(k_r r - i\omega t))$, то в объёме кристалла возникает когерентная суперпозиция этой волны и дифрагиров. волны $E_h \exp(i(k_g r - i\omega t))$ (E_0, E_h — векторы напряженности электрич. поля падающей и дифрагиров. волн соответственно, k_0, k_h — их волновые векторы, r — радиус-вектор точки наблюдения, ω — круговая частота, t — время, $h = k_h - k_0$ — вектор обратной решётки, направленный перпендикулярно отражающим плоскостям, величина $h = 2\pi/d$, d — межплоскостное расстояние, n — порядок отражения).

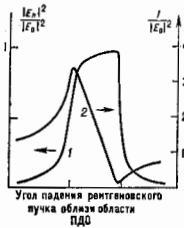
Интенсивность $I(z)$ поля излучения в Р. с. в не зависит от t и равна

$$I(z) = |E_0|^2 \left[1 + \frac{|E_h|^2}{|E_0|^2} + 2 \frac{|E_h|}{|E_0|} \cos \left(\frac{2\pi n}{d} z + \alpha \right) \right], \quad (*)$$

где z — координата вдоль вектора обратной решётки, α — фаза комплексного отношения E_h/E_0 . Значения отношения $|E_h|/|E_0|$ и фазы α зависят от конкретных условий, в частности от степени выполнения условия Брэгга — Вульфа и геометрии дифракции. При дифракции в геометрии Лауэ (вектор h параллелен поверхности кристалла) возникают две Р. с. в., для к-рых при точном выполнении условий Брэгга — Вульфа $|E_h| = |E_0|$, а фазы α равны нулю и π . Соответственно в одной волне положения лучности совпадают с положением атомных плоскостей (в первом порядке отражения), а во второй — лучности располагаются между атомными плоскостями.

При дифракции в геометрии Брэгга (вектор h перпендикулярен поверхности кристалла) в толстом кристалле, полностью поглощающем падающее излучение, существует одна Р. с. в. Условие $|E_h| \approx |E_0|$ выполняется в нек-рой области углов падения — в т. н. области полного дифракц. отражения (ПДО), причём фаза α непрерывно меняет своё значение от нуля до π при сканировании через эту область.

Возникновение в кристалле Р. с. в. приводит к существ. изменению всех процессов взаимодействия рентг. излучения с веществом, в первую очередь процессов неупругого рассеяния (фотоэлектрич. поглощения, комптоновского рассеяния, теплового диффузного рассеяния). Эти изменения в свою очередь приводят к аномальной угл. зависимости интенсивности вылетающих из кристалла рентг. фотоэлектронов, рентг. флуоресцентного излучения, диффузного излучения, угл. зависимости рентгено-эдс и др. процессов. Типичные кривые угл. зависимости коэф. рентг. отражения $|E_h|^2/|E_0|^2$ (кривая 1) и интенсивности поля излучения на атомных плоскостях (кривая 2) при дифракции в геометрии Брэгга приведены на рис. Кривая 2 описывается ф-лой (*) при $z=0$, т. е. на поверхности кристаллич. пластины. В области полного дифракц. отражения, т. е. когда $|E_h| \approx |E_0|$, изменение интенсивности обусловлено только монотонным изменением фазы α от нуля до π . При этом углы и лучности Р. с. в. перемещаются на половину межплоскостного расстояния.



Рентг. излучение при взаимодействии с веществом выбивает электроны в осн. из внутр. оболочек атомов. Эти электроны сильно локализованы вблизи атомных ядер и реагируют на наличие поля излучения только вблизи ядра. Поэтому угл. зависимость поглощения веществом рентг. излучения приблизительно описывается кривой 2. В точке, для к-рой $\alpha = \pi$, поглощение резко уменьшается, что является причиной аномального пропускания эффекта. Но наиб. ярко этот эффект проявляется в геометрии Лауэ, когда рентг. лучок падает под большим углом к поверхности кристалла, а коэф. экспоненциального затухания интенсивности уменьшается в десятки раз.

Возникновение Р. с. в. следует из общей динамич. теории дифракции рентг. лучей, разработанной П. П. Эвальдом (P. P. Ewald) и Ч. Дарвином (Ch. Darwin) в нач. 20 в., однако первым косвенным эксперим. доказательством их существования явилось наблюдение Х. Борманом (H. Vogtsman) в 1941 эффекта аномального пропускания. Наиб. прямое доказательство существования Р. с. в. — измерение выхода вторичных излучений. Первый такой эксперимент был выполнен в 1962 Б. В. Баттерманом (B. W. Battermann), к-рый измерил выход флуоресценции Ge К α при дифракции MoK α -излучения в кристалле Ge в геометрии Брэгга. Однако ему

не удалось получить криему 2, впервые она была получена в 1970 В. Н. Шмельевым, М. В. Игровым и В. П. Прониным при измерении фотоэлектронной эмиссии в монокристаллах Ge и Si.

Метод Р. с. в. используется для исследования структур тонких приповерхностных слоев монокристаллов, деформированных в результате внешних воздействий (диффузии примесей, ионной имплантации, эпитаксиального наращивания плёнок разл. состава и т. д.). Этим методом изучают также структурное состояние пригосных атомов в кристаллах и адсорбиров. слоев на его поверхности, определяют степень аморфизации приповерхностных слоев, измеряют разбухание кристаллич. структуры, приводящее к сдвигу атомных плоскостей по сравнению с исходным положением на малые доли ангстрема.

Ширина угл. области полного дифракц. отражения составляет величину порядка угл. секунды ($\sim 0,5 \cdot 10^{-5}$ рад). Поэтому для эфф. развития метода разработаны прецизионная гониометрич. аппаратура (см. *Рентгеновский гониометр*), работающая в автоматич. режиме и управляемая ЭВМ. С помощью этой аппаратуры кристалл можно поворачивать в прямом и обратном направлениях через положение полного дифракц. отражения в течение неск. ч, причём положение кристалла сохраняется с точностью до сотых долей угл. секунды. Разрабатываются также новые эфф. счётчики вторичных излучений.

Р. с. в. возникают также при динамич. дифракции др. типов излучений (электронов, нейтронов, ядерного гамма-излучения) с длиной волны ок. 10 нм.

Лит.: К о в а л ь с к и й М. В., К о н В. Г. Рентгеновские

сточные волны — новый метод исследования структуры кристаллов. *«УФН»*, 1986, т.149, с. 69.

В. Г. К о н.

РЕНТГЕНОВСКИЙ ГОНИОМЕТР — прибор для одновремен. регистрации направления дифрагированного на исследуемом образце рентг. излучения и положения образца в момент возникновения дифракции. Р. г. может быть самостоят. прибором, регистрирующим на фотоплёнке или пластине с фотосуммулирующ. люминесцирующей дифракц. картинку; в этом случае он представляет собой *рентгеновскую камеру*. Р. г. называют также все гониометрич. устройства, являющиеся составной частью *рентгеновских дифрактометров* и служащие для установления образца в положение, соответствующее условиям возникновения *дифракции рентгеновских лучей*, и детектора — в направлении дифрагиров. лучей.

В Р. г. с фоторегистратией или с люминесцирующими пластинами для исследования монокристаллов или текстур выделяют дифракц. кокус, соответствующий при вращении образца исследуемой кристаллографич. плоскости в обратном пространстве. Фотоплёнка и образец движутся синхронно, поэтому одна на координат на плёнке соответствует азимутальному углу дифрагиров. луча, вторая — углу поворота образца (так работают Р. г. Вайсберга (рис. 1) и текстурный Р. г. Жданова). В Р. г. дифрактометров для монокристаллов может быть использована аналогичная геом. схема,

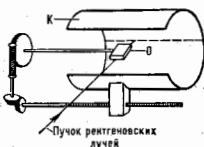
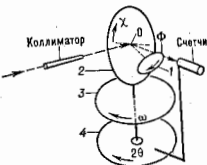


Рис. 1. Схема рентгеновского гониометра типа Вайсберга. Зубчатые передачи и ходовой винт обеспечивают синхронное движение исследуемого образца (О) и цилиндрической камеры (К) с рентгеновской плёнкой.

однако угол поворота образца и углы поворота и наклона счётчика в этом случае отсчитываются непосредственно по угл. датчикам, установленным на соответствующих валах. В случае использования двумерных позиционно-чувствит. детекторов в гониометре

отсчитывается только угол поворота образца, а углы поворота и наклона дифрагиров. пучка пересчитываются из координат дифракц. пикта в детекторе. В рентг. дифрактометрах для исследования монокристаллов и текстур с точечным счётчиком широко применяется т. н. экваториальная геометрия: счётчик перемещается только в одной экваториальной плоскости, а образец поворачивается вокруг трёх взаимно перпендикулярных осей таким образом, чтобы нормаль к заданной кристаллографич. плоскости в отражающем положении располагалась в экваториальной плоскости (рис. 2).

Рис. 2. Схема экваториальной четырёхкружной гониометра для исследования монокристаллов. Лимб 1 измеряет Φ — угол поворота кристалла вокруг оси гониометрической головки; лимб 2 регистрирует χ — угол наклона оси Ф; лимб 3 измеряет ω — угол вращения кристалла относительно главной оси гониометра; лимб 4 измеряет угол поворота счётчика 2 θ .



В Р. г. для исследования монокристаллов на образец направляется пучок с сечением $\sim 0,1 \div 0,5$ мм, сфокусированный коллиматором, состоящим из двух крупных дифрагми или двух фокусирующих зеркал полного внос. отражения (см. *Рентгеновская оптика*). Чаще всего излучение монохроматизируется с помощью монохроматора из пиролинич. графита.

В Р. г. для исследования поликристаллич. образцов для повышения интенсивности дифракц. излучения используют первичные пучки с расходямостью в неск. градусов. Для получения высокого (в сотни и тысячи раз) разрешения применяются фокусирующие схемы Брэгга — Брентано, Земана — Болина или Гилье. Эти Р. г. являются дуэсными, а двумя коаксиальными осями. Для формирования пучков в них используются щели, монохроматизация пучков осуществляется с помощью фокусирующих монохроматоров на монокристаллах или пиролинич. графита на первом и дифрагиров. пучках, а также селективных фильтров.

В одноосных малоугловых Р. г. основой является щелевой коллиматор, обеспечивающий мин. расходямость первичного пучка. Особенность Р. г. для исследования приповерхностных слоев монокристаллов методом *рентгеновских стоксских волн* — наличие встроенного пропорц. счётчика электронов, анализирующего электроны, выходящие из образца при дифракции рентг. лучей.

Лит.: У г л а н в и с к и й М. А. Анализ рентгеноструктурных исследований, М., 1960; Х е й е р Д. М., Рентгеновая дифрактометрия монокристаллов, Л., 1973; Современная кристаллография, т. 1, М., 1979.

Д. М. Х е й е р.

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИФРАКТОМЕТР — прибор для измерения интенсивности и направления рентг. пучков, дифрагированных на исследуемом образце (см. *Дифракция рентгеновских лучей*). Р. д. применяется для решения разл. задач *рентгеновского структурного анализа*, *рентгенографии материалов*, исследования реальной структуры монокристаллов. Он позволяет измерять интенсивность дифрагированного в заданном направлении излучения с точностью до десятых долей % и угол дифракции с точностью до неск. минут долей секунды.

Р. д. состоит из источника рентг. излучения, рентг. гониометра, в к-рый помещают исследуемый образец, детектора излучения, электронного измерительного регистрирующего устройства, управляющей ЭВМ. В Р. д. в отличие от камер для регистрации излучения не используют фотоматериалы или люминесцирующие пластины, а применяют сцинтилляционные, пропорциональные, полупроводниковые детекторы (см. *Детекторы* ч а с т и ц, *Ионизирующее излучение*). В процессе измерения счётчик перемещается в гониометре и регистри-

рует в каждой точке число фотонов дифрагиров. излучения за опред. интервал времени. Используются также одомерные и двумерные позиционно-чувствит. счётчики указанных выше типов, фиксирующие одновременно и факт попадания фотона в детектор и его пространственные координаты в детекторе. Одомерными и двумерными детекторами можно параллельно измерять дифракц. картину во мн. точках и тем самым ускорять регистрацию одновременно возникающей одномерной или двумерной картины и упростить устройство гониометров. Напр., Р. д. для поликристаллич. образцов с одомерным детектором или Р. д. для макромолекулярных кристаллов с двумерным детектором позволяют на два порядка сократить время измерения при соответствующем сокращении дозы облучения образца.

Р. д. обладают более высокими по сравнению с рентг. фотогр. камерами точностью, чувствительностью, экспоненсностью, большим динамич. диапазоном. Процесс получения информации в Р. д. может быть полностью автоматизирован, а обработка может производиться очень быстро, поскольку в них отсутствует необходимость иррадиации фотоплёнки или считывания с пластин фотолуминесценции (рентг. фотогр. камера с регистрацией на пластину с фотосенсибилизированной люминесценцией, оборудованная считывающим устройством, управляемым ЭВМ, по степени автоматизации эквивалентна Р. д.). Универсальные Р. д. для поликристаллич. материалов могут быть использованы для разл. рентгеноструктурных исследований: фазового количества и качеств. анализа, текстурных исследований, изучения фазовых превращений, ориентирования монокристаллов, исследований *малоугольного рассеяния* и т. д., путём замены приставок к гониометрич. устройству. Так, существуют приставки для крупнокристаллич. образцов, исследований текстуры, низкотемпературных (до темп-р жидкого азота и гелия) и высокотемпературных (до темп-р ок. 3000°K) исследований, приставки для ориентирования монокристаллов и т. д. Управляющая ЭВМ и соответствующие программы позволяют автоматически получать дифракц. картину и рассчитывать конечные результаты даже в универсальном Р. д. В больших лабораториях применяются более проводимые и точные специализиров. Р. д., предназначенные для решения к.-д. одной задачи. Источником излучения в Р. д. может быть отапливаемая рентг. трубка с точечной или линейной проекцией фокуса с использованием в качестве коллиматоров соответственно круглых или щелевых диафрагм. Для повышения яркости источника и сокращения времени эксперимента на порядок применяют непрерывно отключаемые рентг. трубки с вращающимся анодом. На два и более порядка можно ускорить дифракц. эксперимент в Р. д., если использовать в качестве рентг. источника синхротронное излучение.

РЕНТГЕНОВСКИЙ ЛАЗЕР — источник когерентного изм.-мал. излучения рентг. диапазона. Иногда используется термин «размер по аналогии с «разер» (см. *Лазер, Гамма-лазер*). Идея создания Р. л. появилась в нач. 1960-х гг. сразу же после создания лазеров. Осн. концепции создания сложились к нач. 70-х гг. Первый лабораторный Р. л. был создан в Ливерморской лаборатории им. Э. Лоуренса (США) в 1985 (была получена генерация на серии линий Ne-подобного иона селена в области 182–263 Å, наиб. яркая из к-рых — линия 206,3 Å). К настоящему времени (1991) получено квазикогерентное рентг. излучение в режиме усиления спонтанного излучения с длиной волны от неск. сотен до десятков ангстрем, напр. 206Å (Se²⁴⁺), 182 Å (C³⁺), 81Å (F²⁺), 46Å (Al¹¹⁺). Длительность импульса генерации Р. л. составляет 0,1–10 пс и определяется, как правило, временем жизни плазменного образования. Величина коэф. усиления за один проход лежит в пределах 3–16. Т. о., макс. усиление отно-

сительно уровня спонтанного излучения составляет $e^{16} \approx 10^7$. Макс. энергия, полученная в импульсе, ~10 МДж, угл. расходимость пучка ~10 мрад. Сравнение параметров импульса лазера накачки и импульса рентг. излучения показывает, что коэф. преобразования по энергии составляет лишь ~10⁻⁸. Однако уже этого достаточно для проведения ряда физ. и биол. экспериментов. Р. л. обладают наивысшей импульсной яркостью по сравнению с др. источниками рентг. излучения.

Активная среда Р. л. — высокоионизиров. плазма с алектронной темп-рой от неск. сотен эВ до неск. кэВ, создаваемая при облучении мишени (напр., тонкой фольги из селена и иттрия) мощными лазерами видимого и ИК-диапазонов. Плазменное образование имеет длину в неск. см (0,5–5 см) и поперечный размер 0,01–0,1 см. Плазма создается, как правило, фокусировкой излучения либо 2-й гармоникой Nd : YAG-лазера (см. *Теоретический лазер*), либо излучения CO₂-лазера, имеющих энергию излучения ~1 кДж и длительность импульса генерации 0,1–10 нс. Энергия, необходимая для создания иона заданной кратности, и плотность атомов активного элемента в мишени определяют плотность энергии лазерного излучения накачки, необходимую для создания активной среды. Пороговые условия генерации Р. л. определяются мн. значениями плотности ионов в плазме. Если длина поглощателя генерируемого рентг. излучения больше длины активной области Л кристалла, то пороговое условие генерации имеет вид

$$\mu_0 L > 1, \quad (1)$$

где резонансный коэф. усиления

$$\mu_0 = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot \frac{\Delta N}{V} \cdot \frac{1}{\Gamma_{\lambda}}; \quad (2)$$

здесь $\Delta N = N_2 - (g_2/g_1)N_1$; N_2 , N_1 — населённости верх. и ниж. рабочих уровней, g_2 , g_1 — кратности их вырождения, Γ — ширина линии усиления, T_1 — спонтанное время жизни. Пороговая уд. мощность накачки определяется условием

$$W > \frac{\hbar\omega}{\delta} \frac{\Delta N}{V} \frac{1}{T_1} \quad (3)$$

или

$$W_{\text{пор}} = \frac{\hbar\omega}{\delta} \frac{4\pi\Gamma}{\lambda^2 L} = \frac{4\pi\hbar c}{\delta \lambda^2 L},$$

где $\hbar\omega = \epsilon_2 - \epsilon_1$, $\delta = (\epsilon_2 - \epsilon_1)/\epsilon_{\text{и}}$ — отношение энергии рабочего перехода к энергии $\epsilon_{\text{и}}$ затрачиваемой на создание иона требуемой кратности на верх. рабочем уровне. В предположении, что лазерное излучение полностью поглощается в слое плазмы, являющейся активной средой и имеющей длину L и поперечный диаметр d , а также что ширина линии усиления определяется доплеровским уширением $\Gamma = \Delta\omega_0 = v/c = 2u_0/\lambda$, пороговая интенсивность лазерного излучения накачки

$$I_{\text{пор}} = \frac{2(2\pi)^2 \hbar c d v_1}{\delta \lambda^2 L}.$$

При $L \sim 1$ см, $d \sim 10^{-2}$ см, $v_1 \sim 10^8$ см/с

$$I_{\text{пор}} \approx \frac{10^{11}}{\lambda^2 \text{ нм}^2} \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2} \quad (4)$$

Требования к мощности накачки не являются очень жесткими в области $\lambda = (0,1-10)$ нм. Гораздо более жесткие требования предъявляются к энерговкладу. Из (4) следует, что

$$E_{\text{пор}} = W_{\text{пор}} T_1 L S \sim \frac{\hbar\omega}{\delta} n_{\text{пор}} L d S; \quad (5)$$

адесь $n_{пор}$ — пороговая концентрация ионов. Если $\delta = 0,1$ и $n_{пор} = 10^{22} \text{ см}^{-3}$, т. е. $n_{пор} \sim$ концентрация атомов в твёрдом теле, то энерговыход на единицу длины активной среды

$$\frac{\epsilon_{пор}}{L} \approx \frac{2 \cdot 10^{-10}}{L(\text{мм})} n_{пор} \approx \frac{2 \cdot 10^4}{L(\text{мм})} \frac{\text{Дж}}{\text{см}} \quad (6)$$

Для значений $ГТ, \approx 10$ и $L \sim 1$ см пороговые значения концентрации ионов, согласно (1) и (2), определяются выражением $n_{пор} \approx 10^{20} \delta^2 \text{ [мм]} \text{ см}^{-3}$, что существенно меньше концентрации атомов в твёрдом теле. Так, при $n_{пор} \approx 10^{16} \text{ см}^{-3}$ из (6) следует $\epsilon_{пор}/L \sim 2 \cdot 10^{-3} \text{ [мм]} \text{ Дж/см}$, что выполняемо для широкого класса систем накачки.

Основные механизмы создания инверсии. Предложено ок. 10 механизмов создания инверсии между уровнями в атомах или ионах активной среды Р. л., некоторые из них являются развитием методов, широко используемых в традиционных оптич., ИК- и УФ-лазерах, другие применимы лишь в рентг. области. Реализованы два механизма: столкновит. возбуждение и рекомбинац. накачка. В лазерной плазме, в отличие от плазмы высокой плотности, распределение частиц по энергетич. уровням может существенно отличаться от равновесного и определяется соотношением скоростей процессов ионизации, рекомбинации электронов и ионов, возбуждения ионов, а также излучат. процессов. При высоких значениях электронной плотности преобладают процессы трёхчастичной рекомбинации: напр., $A^{n+} + e + e \rightarrow (A^n)^* + e$, где $(A^n)^*$ — возбуждённое состояние иона кратности n . Поскольку в этом случае третья частица принимает часть энергии, то электроны оказываются на высоковозбуждённых уровнях иона $(A^n)^*$, последующая релаксация в осн. состоянии идёт либо излучательным, либо столкновит. путём.

В случае низкой плотности электронов преобладают процессы излучат. рекомбинации, когда электрон оказывается на ниж. уровнях иона A^{n+} ; если электронная темп-ра при этом велика, то ион оказывается в осн. состоянии. Указанные процессы и определяют два осн. механизма создания в Р. л. инверсии. Р. л. со ст. о л. к. н. о в т. л. д. к. о. и накачкой по принципу действия гораздо ближе к традиц. лазерам, работающим в видимой области. В этом случае в качестве активной среды используется высокотемпературная плазма низкой плотности. В результате излучат. рекомбинации заселяются осн. состояния рабочих ионов (напр., уровни $2s^2 3p^4$ в случае иона Se^{34+} ; рис.). Верхний рабочий уровень $3p$ заселяется на осн. состоянии при соударениях ионов плазмы с электронами, нижний рабочий уровень $3s$ быстро опустошается за счёт быстрого излучат. распада $3s \rightarrow 2p$. Переход $3p \rightarrow 2p$ запрещён. Генерация рентг. излучения идёт на излучательно разрешённом переходе $3p \rightarrow 3s$. Плазма должна быть оптически тонкой для излучения на переходе $3s \rightarrow 2p$

(с тем чтобы избежать заселения уровня $3s$ в результате явления излучения на переходе $3s \rightarrow 2p$).

В лазерах с рекомбинационной накачкой используется быстрое охлаждение высокоплотной плазмы. В этом случае электроны, оказавшиеся на высоких уровнях иона $(A^n)^*$, начинают релаксировать под влиянием излучат. и столкновит. переходов. Если электронная темп-ра мала, то столкновит. процессы важны лишь при переходах между верх. уровнями, когда $kT_e \geq \hbar\omega_{nm}$, где $\omega_{nm} = (\epsilon_n - \epsilon_m)/\hbar$ —

частота перехода с уровня n с энергией ϵ_n на уровень с энергией ϵ_m . С ростом ω_{nm} сечение столкновит. переходов падает, а палучательных — растёт. Чем ближе уровень к основному, тем выше скорость спонтанных переходов, поэтому возможно возникновение инверсии между возбуждёнными уровнями за счёт того, что ниж. уровень будет опустошаться быстрее, чем верхний. Если скорость притока частиц на верх. рабочий уровень за счёт рекомбинац. процессов будет удовлетворять пороговому условию (3), то в этом случае возможна квазистационарная генерация, к-рая прекратится, когда нарушится пороговое условие из-за охлаждения плазмы. Такой тип генерации рентг. излучения был реализован на *Бальмера серии* аодородоподобных ионов (S^{16+} , Fe^{24+}).

Другие методы накачки. Среди др. методов накачки рентг. переходов атомов и ионов — процессы фотонионизации электронов внутр. оболочек атомов или ионов, фотовозбуждения на верхний рабочий уровень излучением, исходящим от ионов более высокой кратности. Этот метод требует перекрытия спектральных линий ионов разл. кратности, что встречается достаточно часто. Идея накачки за счёт переаарядки ионов близка к идее рекомбинац. лазера. При перемещении ионов с атомными пучками или при распылении плазмы в газ возможны ионизация атомов и образование ионов меньшей кратности. Последние образуются, как правило, в возбуждённом состоянии. Дальнейшие процессы релаксации и возникновение инверсии предположительно будут происходить так же, как и в лазере с рекомбинац. накачкой.

Лит.: Бунин И. Ф., Держнев В. И., Яковлевко С. И., О перспективах усиления света дальнего УФ диапазона (Обзор), «Квантовая электроника», 1981, т. 8, с. 1621; Кеу М. Н., Laboratory production of X-ray lasers, «Nature», 1985, т. 316, п. 314; Мэйлибеш Д. Л. и др., Development of a soft X-ray amplifier, «Phys. Rev. Lett.», 1985, в. 54, п. 110; Elton R. C., X-Ray lasers, N. Y., 1990. А. В. Андреев.

РЕНТГЕНОВСКИЙ МИКРОСКОП. Благодаря малой длине волны рентг. излучения Р. м. может достигать дифракц. разрешения порядка неск. десятков нм и по теоретич. величине разрешения занимает промежуточное положение между оптическим и электронным микроскопами. Он позволяет изучать не только распределение общей плотности вещества, но и распределение плотностей отд. хим. элементов по их характеристич. рентг. излучению (поглощению). В отличие от электронного микроскопа, Р. м. позволяет исследовать живые биол. объекты.

По способу формирования изображения различают проекционный, контактный, отражательный и дифракционный Р. м.; по принципу регистрации Р. м. может быть изображающим, образующим действительное или теневое изображение объекта, или сканирующим (растровым), к-рый регистрирует излучение от одного элемента объекта, находящегося на оптич. осн микроскопа, а полное изображение (растр) создается при последов. перемещении объекта относительно осн микроскопа с помощью прецизионного механизма. Преимущество последнего способа регистрации — независимость разрешения от полевых аберраций оптич. системы и, следовательно, отсутствие ограничений на величину поля зрения, а также меньшая радиац. нагрузка на объект исследования.

Р. м. работает в широком диапазоне энергий рентг. квантов — от десятков эВ до десятков кэВ. В ДВ-части спектра наиб. важен участок длин волн 2,3—4,4 нм, соответствующий т. н. «водяному окну», в к-ром достигается наиб. контраст между содержанием углерод органич. веществом живых клеток и жидкой цитоплазмой. Р. м., работающие в КВ-части диапазона, применяются для исследования структуры разл. конструкц. материалов, содержащих элементы с большим ат. номером.

Проекционный рентгеновский микроскоп для наблюдения структуры самосветящихся объектов представля-

ет собой камеру-обскуру (рис. 1,а), отверстие находится на малом расстоянии (S_1) от источника O и на большом (S_2) — от регистрирующего экрана \mathcal{E} или детектора. Увеличение такого проекционного Р. м. $M = S_2/S_1$, разрешение определяется диаметром отверстия d и условиями дифракции, дифракц. предел составляет $\delta \approx (\lambda S_1)^{1/4}$.

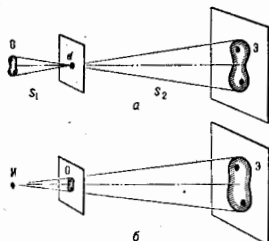


Рис. 1. Схемы проекционных рентгеновских микроскопов для исследования структуры самосветящихся (а) и просвечиваемых (б) объектов; O — объект; I — источник излучения; \mathcal{E} — экран.

В просвечиваемом проекционном Р. м. (рис. 1,б) микрофокусный рентг. источник I создаёт теньное изображение объекта O на экране \mathcal{E} , регистрируемое на фотоплёнку или детектором тельурида. Для источника конечного размера d разрешение такого Р. м. определяется суммой $\delta_t = \delta + \delta'$, где $\delta' = d(S_2/S_1)$, и в обычном случае составляет ~ 1 мкм. Недостатки проекционного Р. м. — малая апертура и большая радиационная нагрузка на просвечиваемый объект.

Контактный рентгеновский микроскоп является предельным случаем проекционного Р. м. при S_2 , равном толщине образца, к-рый устанавливается в непосредственном контакте с фотоплёнкой или экраном. Этот метод иногда называют микрорадиографией. Источник I устанавливается на значит. удалении от образца O , причём размер и соответственно мощность источника могут быть значительно больше, чем в случае проекционного Р. м. Разрешение зависит от толщины образца t и контраста между «тёмными» и «светлыми» деталями объекта, в дифракц. пределе $\delta \approx (\lambda t)^{1/4}$. Напр., при $\lambda = 3$ нм и $t = 3$ мкм $\delta \approx 100$ нм. Для регистрации изображений с таким разрешением используют фоторезисты, применяемые в фотолитографии и имеющие существенно более высокое соств. разрешение (напр., для резиста ПММА — 5 нм). После проявления или травления изображение объекта увеличивается с помощью электронного или оптич. микроскопа.

Отражательный рентгеновский микроскоп может быть и изображающим, и сканирующим, с оптикой скользящего падения или нормального падения с многослойным покрытием (см. Рентгеновская оптика). Р. м. этого типа работают в области $\theta < 4$ кэВ, рассматривается возможность осуществить эту схему Р. м. для более «жёсткого» излучения (в области $\theta \sim 10$ кэВ). Классич. тип отражательного Р. м. скользящего падения — микроскоп Кирпатрика — Базаа, состоящий из пары скрещённых сферич. или цилиндрич. зеркал (рис. 2). В этой схеме источник O и зеркала A и B расположены таким образом, что меридиональное O' и сагиттальное O'' астигматические промежуточные изображения источника (см. Изображение оптическое), создаваемые зеркалом A , были бы соответственно сагиттальным и меридиональным изображениями для зеркала B , к-рое благодаря обратности объекта и изображения создаёт стигматическое увеличенное изображение источника в точке O_1 . Предельное дифракц.

разрешение таких Р. м. $\approx \lambda/20_{кр}$ ($\theta_{кр}$ — критич. угол полного внеш. отражения). Для одиородных покрытий $\theta_{кр} \sim \lambda$, поэтому это отношение не зависит от λ и в области $0.1 < \theta < 4$ кэВ для наиб. плотных металл. покрытий (напр., платины) составляет 5–7 нм. Реальное разрешение Р. м. Кирпатрика — Базаа определяется сферич. aberrацией и комой и обычно составляет

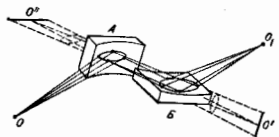


Рис. 2. Схема отражательного рентгеновского микроскопа скользящего падения Кирпатрика — Базаа; O — источник (излучающий объект); A и B — сферические или цилиндрические зеркала; O' и O'' — промежуточные астигматические изображения; O_1 — действительное изображение.

1 мкм. Оно может быть повышено только за счёт уменьшения размеров зеркал λ , следовательно, светосилы, к-рая в результате не намного превышает светосилу проекционного Р. м.

Значительно большей (на 2–3 порядка) светосилой обладают отражательные Р. м. скользящего падения с зеркальными системами Вольтера, из к-рых чаще используется система гиперболоид–эллипсоид (см. рис. 2 в ст. Рентгеновская оптика). Теоретич. разрешение таких Р. м. на оптич. оси определяется соотношением $\delta \approx (1 + M)\lambda/4\theta$, где M — увеличение, θ — угол скольжения, примерно равный $1/6$ апертуры. Напр., для сканирующего Р. м., дающего уменьшенное изображение источника в плоскости просвечиваемого объекта $M = 0.3$ и $\theta = 3^\circ$, при $\lambda = 2.5$ нм $\delta = 5$ нм. Реальное разрешение зависит от точности изготовления зеркал, имеющих глубоко асферическую форму, и составляет ~ 1 мкм; необходимая для получения теоретич. разрешения точность (~ 1 нм) пока недостижима для совр. технологии. Полевые aberrации отражат. Р. м. этого типа довольно велики и ограничивают поле зрения до угл. величины $\sim 1^\circ$. Использование многослойных интерференц. покрытий позволяет увеличить угол θ и тем самым повысить светосилу отражательного Р. м. скользящего падения.

Весьма перспективны отражательный Р. м. нормального падения по схеме Шварцшильда, в к-ром используются зеркала с многослойным покрытием (рис. 3).

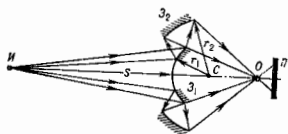


Рис. 3. Схема отражающего рентгеновского микроскопа с зеркалами нормального падения по схеме Шварцшильда; I — источник; \mathcal{Z}_1 и \mathcal{Z}_2 — зеркала с многослойным покрытием; O — объект; \mathcal{D} — приёмник излучения.

Сканирующий микроскоп этого типа даёт уменьшенное изображение источника I с помощью зеркал сферич. формы, расположенных почти concentрически. Для заданных параметров: числовой апертуры A , коэф. уменьшения M и расстояния от источника до первого зеркала S — существуют такие оптич. значения радиусов кривизны зеркал r_1 и r_2 и расстояния между ними, при к-рых сферич. aberrация, кома и астигма-

тним практически отсутствуют. Дифракц. разрешение на оптич. оси определяется, как и для оптич. микроскопа, отношением λ/Δ , при типичном значении $\Delta = 0,3-0,4$ в диапазоне $\lambda = 10-20$ нм оно составляет 30-50 нм. Достижение такого разрешения требует точного изготовления зеркал и их взаимной юстировки с точностью порядка $\lambda/4$.

В дифракционном рентгеновском микроскопе осн. элементом является зонная пластинка Френеля, к-рая для монохроматич. излучения представляет собой линзу с фокусным расстоянием $f = r_1^2/\lambda m$, где r_1 — радиус первой зоны Френеля, λ — длина волны, m — порядок спектра. Дифракц. разрешение зонной пластинки Френеля определяется шириной крайней зоны: $\delta_m = 1,22 \Delta r_1/m = 0,61 r_1/m\sqrt{n}$, где n — номер крайней зоны. Светосила определяется диаметром $d = 2r_1\sqrt{n}$. Эффективность дифракции для зонных пластинок Френеля с амплитудной модуляцией составляет ок. 10% в первом, 2% — во втором и 1% — в третьем порядках спектра. Дифракц. Р. м. обычно работает в области $\theta < 1$ кэВ, т. к. для более жесткого излучения токопроводящие зонные пластинки Френеля становятся прозрачными.

Схема изображающего дифракц. Р. м. приведена на рис. 4. В качестве источника наиб. часто используются синхротроны, накопит. кольца или осцилляторы, излучение к-рых предварительно монохроматизуют до

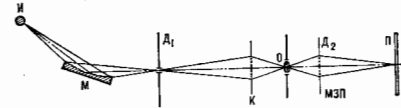


Рис. 4. Схема дифракционного рентгеновского микроскопа с зонными пластинками Френеля; И — источник излучения; D_1 и D_2 — диафрагмы; М — монохроматор с дифракционной решеткой; К — зонная пластинка Френеля — конденсор; МЗП — микрозонная пластинка; О — объект; П — приемник излучения.

спектральной ширины $\Delta\lambda \approx \lambda/m$ и с помощью конденсора направляют на образец О, устанавливаемый в плоскости диафрагмы Д. Микрозонная пластинка (МЗП) даёт увеличенное изображение объекта в плоскости детектора. Доза облучения образца существенно снижается в сфокусирующем дифракц. Р. м., в к-ром используется только одна фокусирующая зонная пластинка. Дифракц. Р. м. обеспечивали (в 1991) наиб. высокое из всех Р. м. разрешение (~ 50 нм), к-рое определяется предельными возможностями технологии изготовления зонных пластинок.

Применение рентгеновских микроскопов. Р. м. наиб. перспективны для задач биологии и медицины (рис. 5, 6). Они позволяют исследовать важные живые биол. объекты — одноклеточные организмы, срезы тканей, отд. клетки, их ядра (без доп. окрасивания). Использование «мягкого» рентг. излучения вблизи лосос поглощения лёгких элементов даёт возможность исследовать распределение этих элементов в структуре объекта. Биополимеры, состоящие из макромолекул (белки, нуклеиновые кислоты и т. д.), эффективно изучаются высокоразрешающим методом контактной рентг. микроскопии. Использование импульсных источников даёт возможность исследовать динамику процессов в вестационных объектах (напр., живых клетках). Для получения трёхмерных изображений тканей в медицине разрабатываются методы компьютерной рентгеновской томографии микрообъектов.

Р. м. успешно применяется в материаловедении при изучении особенностей структуры полукристаллических, полимерных и композитных материалов (рис. 7).

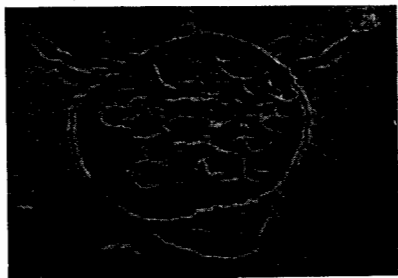


Рис. 5. Контактное микрографическое изображение живого тромбоцита человека, полученное с использованием импульсного рентгеновского источника (плазма пробоя в газе). На изображении различимы детали размером менее 10 нм.

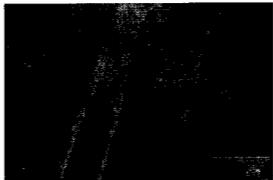


Рис. 6. Изображение диатомовых водорослей, полученное с помощью дифракционного рентгеновского микроскопа. Длина волны излучения 4,5 нм. Масштаб соответствует 1 мкм.

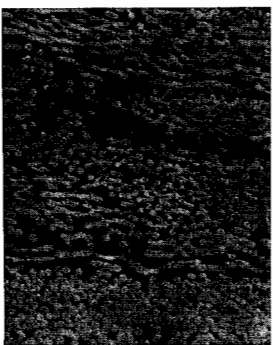


Рис. 7. Контактное микрографическое изображение образца композитного материала (стеклопластик). Светлые участки — стеклянные волокна (диаметр ок. 10 мкм), темные — полимер. Изображение характеризует плотность, однородность и распределение волокон. Толщина образца 400 мкм, энергия рентгеновских квантов $\theta < 30$ кэВ.

Для развития методов рентг. микроскопии важное значение имеет создание высокоинтенсивных источников рентг. излучения. Один из перспективных источников — высокотемпературная лазерная плазма. С помощью изображающих зеркальных Р. м. изучается структура и динамика процессов, происходящих в такой плазме.

Весьма перспективно развитие голографии, микроскопии с применением частично или полностью когерентных источников рентг. излучения, в т. ч. *рентгеновских лазеров*.

Лит.: Рентгенован оптик и микроскопия, под ред. Г. Шваля и Д. Рупольфа, пер. с англ., М., 1987. В. А. Сажин.

РЕНТЕГЕНОВСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — см. Рентгеноспектральный анализ.

РЕНТЕГЕНОВСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ (рентгеноструктурный анализ) — методы исследования атомного строения вещества по распределению в пространстве и интенсивности рассеянного на анализируемом объекте рентг. излучения. Р. с. а. кристаллич. материалов позволяет устанавливать координаты атомов с точностью до 0,1—0,01 нм, определять характеристики тепловых колебаний этих атомов, включая анизотропию и отклонения от гармонич. закона, получать по эксперим. дифракц. данным распределения в пространстве плотности валентных электронов ва хим. связях в кристаллах и молекулах. Этими методами исследуются металлы и сплавы, минералы, неорганич. и органич. соединения, белки, нуклеиновые кислоты, вирусы. Спец. методы Р. с. а. позволяют изучать полимеры, аморфные материалы, жидкости, газы.

Среди дифракц. методов исследования атомного строения вещества Р. с. а. является наиб. распространенным и развитым. Его возможности дополняют методы нейтронографии и электронографии. Дифракц. картина зависит от атомного строения изучаемого объекта, характера и длины волны рентг. излучения. Для установления атомного строения вещества наиб. эффективно использование рентг. излучения с длиной волны $\lambda \sim 10$ нм и меньше, т. е. порядка размеров атомов. Особено успешно и с высокой точностью методами Р. с. а. исследуют атомное строение кристаллич. объектов, структура к-рых обладает строгой периодичностью, и они, т. о., представляют собой естеств. трехмерную дифракц. решётку для рентг. излучения.

Историческая справка

В основе Р. с. а. кристаллич. вещества лежит учение о строении кристаллов. В 1890 рус. кристаллограф Е. С. Фёдоров и нем. математик А. Шёнфлис (A. Schönflies) завершили вывод 230 пространственных групп симметрии, характеризующих все возможные способы размещения атомов в кристаллах. Дифракция рентг. лучей на кристаллах, составляющая эксперим. фундамент Р. с. а., была открыта в 1912 М. Лауэ (M. Laue) и его сотрудниками В. Фридрихом (W. Friedrich) и П. Кинипингом (P. Kipping). Разработанная Лауэ теория дифракции рентг. лучей на кристаллах позволила связать длину волны излучения λ , линейные размеры элементарной ячейки кристалла a, b, c , углы падающего $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ и дифракционного α, β, γ лучей соотношениями

$$\begin{aligned} a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) &= h, \\ b(\cos\beta - \cos\beta_0) &= k, \\ c(\cos\gamma - \cos\gamma_0) &= l, \end{aligned} \quad (1)$$

где h, k, l — целые числа (индексы кристаллографические). Соотношения (1) получили название уравний Лауэ, выполнение их необходимо для возникновения дифракц. лучей рентг. луча на кристалле. Смысл уравний (1) в том, что разности хода между параллельными лучами, рассеянными атомами, отвечающими соседним узлам решётки, должны быть целыми кратными λ .

В 1913 У. Л. Брэгг (W. L. Bragg) и Г. В. Вульф показали, что дифракц. рентг. пучок можно рассматривать как отражение падающего луча от некой системы кристаллографич. плоскостей с межплоскостным расстоянием d :

$$2d \sin \theta = n\lambda,$$

где θ — угол между отражающей плоскостью и дифракц. лучом (угол Брэгга). В 1913—14 гг. Г. и У. Л. Брэгги впервые использовали дифракцию рентг. лучей для эксперим. проверки предсказанного Л. У. Барлоу (W. Barlow) атомного строения кристаллов NaCl, Cu, алмаза и др. В 1916 П. Дебай (P. Debye) и П. Шеррер (P. Scherrer) предложили и разработали дифракц. методы рентгеноструктурных исследований поликристаллич. материалов (*Дебай — Шеррера метод*).

В качестве источника рентг. излучения использовались (и используются поныне) отпаянные рентг. трубки с анодами из разл. металлов и, следовательно, с различными λ соответствующего характеристич. излучения — Fe ($\lambda = 19,4$ нм), Cu ($\lambda = 15,4$ нм), Mo ($\lambda = 7,1$ нм), Ag ($\lambda = 5,6$ нм). Позднее появились на порядок более мощные трубки с вращающимся анодом, для структурных исследований использующие также наиб. мощный, имеющий белый (непрерывный) спектр излучения источник — рентг. *синхротронное излучение*. С помощью системы монохроматора можно непрерывным образом изменять λ применительно в исследовании синхротронного рентг. излучения, что имеет принципиальное значение при использовании в Р. с. а. эффектов аномального рассеяния. В качестве детектора излучения в Р. с. а. служит рентг. фотоплёнка, к-рую вытесняют сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Эффективные измерит. систем резко возросла с применением координатных одномомерных и двумерных детекторов.

Количество и качество информации, получаемой с помощью Р. с. а., зависит от точности измерений и обработки эксперим. данных. Алгоритмы обработки дифракц. данных определяются используемым приближением теории взаимодействия рентг. излучения с веществом. В 1950-х гг. началось применение ЭВМ в технике рентгеноструктурного эксперимента и для обработки эксперим. данных. Созданы полностью автоматизированные системы для исследования кристаллич. материалов, к-рые проводят эксперимент, обработку эксперим. данных, осц. процедуры по построению и уточнению атомной модели структуры и, наконец, графич. представление результатов исследования. Однако с помощью этих систем пока нельзя изучать в автоматич. режиме кристаллы с псевдосимметрией, двойниковые образцы и кристаллы с др. особенностями структуры.

Экспериментальные методы рентгеновского структурного анализа

Для реализации условий дифракции (1) и регистрации положения в пространстве и интенсивности дифрагированного рентг. излучения служат рентг. камеры и рентг. дифрактометры с регистрирующей излучения соответственно фотогр. методами или детекторами излучения. Характер образца (монокристалл или поликристалл, образец с частично упрощённой структурой или аморфное тело, жидкость или газ), его размер и решаемая задача определяют необходимую экспозицию и точность регистрации рассеянного рентг. излучения и, следовательно, определяемый метод Р. с. а. Для изучения монокристаллов при использовании в качестве источника рентг. излучения отпаянной рентг. трубки достаточен объём образца $\sim 10^{-3}$ см³. Для получения качественной дифракц. картины образец должен обладать возможно более совершенной структурой, причём его блочность не препятствует структурным исследованиям. Реальное строение крупных, почти совершенных монокристаллов исследует *рентгеновская томография*, к-рую иногда тоже относят к Р. с. а.

Метод Лауэ — простейший метод получения рентгенограмм монокристаллов. Кристалл в эксперименте Лауэ неподвижен, а используемое рентг. излучение имеет непрерывный спектр. Расположение дифракц. пятен на лауэграммах зависит от размеров элементар-

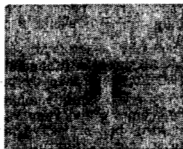
ной ячейки и симметрии кристалла, а также и от ориентации образца относительно падающего рентг. луча. Метод Лауэ позволяет отвести монокристалл к одной из 11 лауэвских групп симметрии и установить ориентацию его кристаллографич. осей с точностью до угла. минут (см. Лауэ метод). По характеру дифракц. пятен на лауэграммах и особенно по появлению астериев (рамытия пятен) можно выявить внутр. напряжения и не-крые др. особенности строения образца. Методом Лауэ проверяют качество монокристаллов и проводят отбор наиб. совершенных образцов для более полного структурного исследования (рентгенгонометрич. методами; см. ниже).

Методами качания и вращения образца определяют периоды повторяемости (трансляции) вдоль заданных кристаллографич. направлений, проверяют симметрию кристалла, а также измеряют интенсивности дифракц. отражений. Образец во время эксперимента приводится в колеб. или вращат. движение относительно осн. совпадающей с одной из кристаллографич. осей образца, к-рую предварительно ориентируют перпендикулярно падающему рентг. лучу. Дифракц. картина, создаваемая монокроматич. излучением, регистрируется на рентг. плёнке, находящейся в цилиндр. кассете, ось к-рой совпадает с осью колебания образца. Дифракц. пятна при такой геометрии съёмки на развёрнутой плёнке оказываются расположенными на семействе параллельных прямых (рис. 1). Период повторяемости T вдоль кристаллографич. направления равен:

$$T = n\lambda \sqrt{1 + (D/2l_n)^2},$$

где D — диаметр кассеты, $2l_n$ — расстояние между соответствующими прямыми на рентгенограмме. Т. к. λ постоянна, условия Лауэ (1) выполняются за счёт изменения углов при качании или вращении образца. Обычно на рентгенограммах качания и вращения образца дифракц. пятна перенрываются. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, можно уменьшить угол, амплитуду колебаний образца. Такой приём применяется, напр., в Р. с. а. белков, где рентгенограммы качания используют для измерения интенсивностей дифракц. отражений.

Рис. 1. Рентгенограмма качания минерала сейдоверита $\text{Na}_2\text{MgTi}(\text{Zr}, \text{Ti})_2\text{O}_4(\text{F}, \text{OH})_2(\text{Si}_4\text{O}_{12})_2$.



Рентгенгонометрические методы. Для полного структурного исследования монокристалла методами Р. с. а. необходимо определить положение в пространстве и измерить интегральные интенсивности всех дифракц. отражений, возникающих при использовании излучения с длиной λ . Для этого в процессе эксперимента образец должен с точностью порядка угла. минут принимать ориентации, при к-рых выполняются условия (1) последовательно для всех семейств кристаллографич. плоскостей образца; при этом регистрируются мн. сотни и даже тысячи дифракц. рефлексов. При регистрации дифракц. картины на рентг. фотодлётке интенсивности рефлексов определяются микроденситометром по степени почернения ρ размеру дифракц. пятен. В разл. типах гониометров реализуются разл. геом. схемы регистрации дифракц. картины. Полный набор интенсивностей дифракц. отражений получают на серии рентгенограмм, на каждой рентгенограмме регистрируются рефлексы, на кристаллографич. индекс которых наложены определ. ограничения. Напр., на разных

рентгенограммах регистрируются отражения типа hkl_0, hkl_1 (рис. 2). Для установления атомой структуры кристалла, в элементарной ячейке к-рого содержится ~ 100 атомов, необходимо измерить неск. тысяч дифракц. отражений. В случае монокристаллов белков объём эксперимента возрастает до $10^4 - 10^6$ рефлексов.

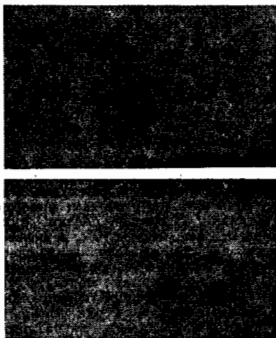


Рис. 2. Рентгенограмма минерала сейдоверита, полученная в рентгеновском гониометре Вайсберга. Зарегистрированные дифракционные отражения имеют вид линий, расположенные на одной кривой, характеризуются постоянным индексом k .

При замене фотодлётки на счётчики рентг. квантов возрастают чувствительность и точность измерения интенсивностей дифракц. отражений. В совр. автоматич. дифрактометрах предусмотрены 4 оси вращения (3 у образца и 1 у детектора), что позволяет реализовать в них различные по геометрии методы регистрации дифракц. отражений. Такой прибор универсален, управление им осуществляется с помощью ЭВМ и специально разработанных алгоритмов и программ. Наличие ЭВМ позволяет ввести обратную связь, оптимизацию измерений каждого дифракц. отражения и, следовательно, естеств. образом планировать весь дифракц. эксперимент. Измерения интенсивностей производятся с необходимой для решающей структурной задачи статистич. точностью. Однако увеличение точности измерений интенсивностей на порядок требует увеличения времени измерений на два порядка. На точность измерений накладывает ограничение качество исследуемого образца. Для белковых кристаллов (см. ниже) сокращение времени эксперимента осуществляется за счёт использования двумерных детекторов, в к-рых параллельно идёт измерение мн. десятков дифракц. отражений. При этом утрачивается возможность оптимизации измерений на уровне отд. рефлекса.

Метод исследования поликристаллов (метод Дебая — Шеррера). Для Р. с. а. кристаллич. порошков, керамики, материалов и др. поликристаллич. объектов, состоящих из большого числа мелких, случайным образом ориентированных друг относительно друга монокристаллов, используется монокроматич. рентг. излучение. Рентгенограмма от поликристаллич. образца (дебаграмма) представляет собой совокупность концентрич. колец, каждое из к-рых состоит из дифракц. отражений от разл. образом ориентированных в разных зёрнах систем кристаллографич. плоскостей с определённым межплоскостным расстоянием d . Набор d и соответствующие им интенсивности дифракц. отражений индивидуальны для каждого кристаллич. вещества. Метод Дебая — Шеррера используется при

идентификации соединений и анализе смесей поликристаллич. веществ по качеств. и количеств. составу составляющих смеси фаз. Анализ распределения интенсивностей в дебаевских кольцах позволяет оценить размеры зёрен, наличие напряжений и преимущественных ориентаций (текстурирования) в расположении зёрен (см. Рентгенография материалов, Дебаа — Шеррера метод).

В 1980 — 90-х гг. в Р. с. а. стал применяться метод уточнения атомного строения кристаллич. веществ по дифракц. данным от поликристаллич. материалов, предложенный Х. М. Ритвелдом (H. M. Rietveld) для нейтронографич. исследований. Метод Ритвелда (метод полнопрофильного анализа) используется в том случае, когда известна приближённая структурная модель изучаемого соединения, но точности результатов он может конкурировать с рентгеноструктурными методами исследования монокристаллов.

Исследование аморфных материалов и частично упорядоченных объектов. Чем ниже степень упорядоченности атомного строения анализируемого вещества, тем более размытый, диффузный характер имеет рассеяние им рентг. пучка. Однако дифракц. исследование даже аморфных объектов даёт возможность получить информацию об их строении. Так, диаметр диффузного кольца на рентгенограмме от аморфного вещества (рис. 3) позволяет оценить ср. межатомные



Рис. 3. Рентгенограмма аморфного вещества — ацетата целлюлозы.

расстояния в нём. С ростом степени упорядоченности в строении объектов дифракц. картина усложняется (рис. 4) и, следовательно, содержит больше структурной информации.

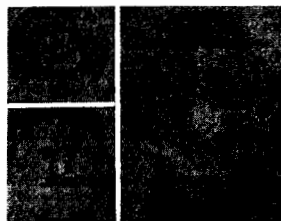


Рис. 4. Рентгенограммы биологических объектов: а — волоса; б — натриевой соли ДНК во водном состоянии; в — текстуры натриевой соли ДНК.

Метод малоуглового рассеяния. В том случае, когда размеры неоднородностей в объекте исследования превышают межатомные расстояния и составляют от 0,5—1 до 10³ нм, т. е. во много раз превышают длину волны используемого излучения, рассеяние рентг. излучение концентрируется вблизи первичного пучка — в области малых углов рассеяния. Распределение интенсивности в этой области отражает особенности строения исследуемого объекта. В зависимости от строения объекта и размеров неоднородностей интенсивность рентг. рассеяния измеряют в углах от долей минут до неск. градусов.

Малоугл. рассеяние применяют для изучения пористых и мелкодисперсных материалов, сплавов и биол. объектов. Для молекулы белка и нуклеиновых кислот в растворах метод позволяет с невысоким разрешением определять форму и размеры индивидуальной молекулы, мол. массу, в вирусах — характер взаимной укладки составляющих их компонент (белка, нуклеиновых кислот, липидов), в светитч. полимерах — упаковку полимерных цепей, в порошках и сорбентах — распределение частей и пор по размерам, в сплавах — фиксировать возникновение новых фаз и определять размеры этих включений, в текстурах (в частности, в жидких кристаллах) — упаковку частиц (молекул) в различного рода надмолекулярные структуры. Эффективным оказался метод малоугл. рассеяния и для исследования строения легимированных плёнок. Он применяется также в пром-сти при контроле процессов приготовления катализаторов, высокодисперсных углей и т. д.

Анализ атомной структуры кристаллов

Определение атомной структуры кристаллов включает: установление формы и размеров элементарной ячейки, симметрии кристалла (его принадлежности к одной из 230 фёдоровских групп) и координат базисных атомов структуры. Прецизионные структурные исследования позволяют, кроме того, получать количеств. характеристика тепловых движений атомов в кристалле и пространственное распределение в нём валентных электронов. Методами Лауэ и качения образца определяют метрику кристаллич. решётки. Для дальнейшего анализа необходимо измерение интенсивностей всех возможных дифракц. отражений от исследуемого образца при данной λ. Первичная обработка эксп-им. данных учитывает геометрию дифракц. эксп-имента, поглощения излучения в образце, поляризацию и др. более тонкие эффекты взаимодействия пучка с образцом.

Трёхмерная периодичность кристалла позволяет разложить распределение его электронной плотности ρ(x,y,z) в пространстве в ряд Фурье:

$$\rho(x, y, z) = V^{-1} \sum_{hkl} F_{hkl} \exp[-2\pi i(hx + ky + lz)], \quad (2)$$

где V — объём элементарной ячейки кристалла, F_{hkl} — коэффициенты Фурье, к-рые в Р. с. а. наз. структурными амплитудами. Каждая структурная амплитуда характеризуется целыми числами h, k, l — кристаллографич. индексами в соответствии с (1) и однозначно отвечает одному дифракц. отражению. Разложение (2) физически реализуется в дифракц. эксп-именте.

Осн. сложность структурного исследования состоит в том, что обычный дифракц. эксперимент даёт возможность измерить интенсивности дифракц. пучков I_{hkl}, но не позволяет фиксировать их фазы φ_{hkl}. Для мозаичного кристалла в кинематич. приближении I_{hkl} ~ |F_{hkl}|². Анализ эксп-им. массива |F_{hkl}| с учётом закономерных погасаний рефлексов позволяет однозначно установить его принадлежность к одной из 122 рентг. групп симметрии. При отсутствии аномального рассеяния дифракц. картина всегда центросимметрична. Для определения фёдоровской группы симметрии необходимо независимо выяснить, обладает ли кристалл центром симметрии. Эта задача может быть решена на основе анализа аномальной составляющей рассеяния рентг. лучей. При отсутствии последнего строят кривые статистич. распределения |F_{hkl}| по их значениям, эти распределения различны для центросимметричных и ацентричных кристаллов. Отсутствие центра симметрии может быть однозначно установлено и по фаз. свойствам кристалла (пьезоэлектрическим, сегнетоэлектрическим и др.).

Фурье-преобразование соотношения (2) позволяет получить расчётные ф-лы для вычисления величины F_{hkl} (в общем случае — комплексных):

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^N f_j \exp [2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)], \quad (3)$$

где $f_j(\sin\theta/\lambda) = at$ — фактор рассеяния рентг. излучения атомом j ; x_j, y_j, z_j — его координаты; суммирование идёт по всем N атомам элементарной ячейки.

Задача, обратная структурному исследованию, решается следующим образом: если известна атомная модель структуры, то по (3) вычисляются модули и фазы структурных амплитуд и, следовательно, интенсивности дифракц. отражений. Дифракц. эксперимент даёт возможность измерить ин. сотия не связанных симметрией амплитуд $|F_{hkl}|$, каждая из k -рых определяется по (3) набором координат базисных (независимых по симметрии) атомов структуры. Таких структурных параметров существенно меньше, чем модулей $|F_{hkl}|$, следовательно, между последними должны существовать связи. Теория структурного анализа устанавливает связи равного типа: неравенства, линейные неравенства, структурные произведения и детерминанты связи структурных амплитуд.

На основе наиб. эффективных статистич. связей развития [Дж. Карле (J. Karle) и Х. А. Хауптман (H. A. Hauptman), Нобелевская премия, 1985] т. н. прямые методы определения фаз структурных амплитуд. Если взять тройку больших по модулям структурных амплитуд, индексы k -рых связаны простыми соотношениями $h_1 + h_2 + h_3 = 0, k_1 + k_2 + k_3 = 0, l_1 + l_2 + l_3 = 0$, то наиб. вероятная сумма фаз этих амплитуд будет равна нулю:

$$\varphi_{h_1k_1l_1} + \varphi_{h_2k_2l_2} + \varphi_{h_3k_3l_3} \approx 0.$$

Вероятность выполнения равенства тем выше, чем больше произведение спец. образом нормированных структурных амплитуд, входящих в это соотношение. С ростом числа атомов N в элементарной ячейке кристалла надёжность соотношения падает. На практике используются существенно более сложные соотношения и достаточно строгие оценки вероятностей выполнения этих соотношений. Вычисления по этим соотношениям весьма громоздки, алгоритмы сложны и реализуются только на мощных совр. ЭВМ. Прямые методы дают первые приближённые значения фаз и только наиб. сильных по нормированным модулям структурных амплитуд.

Для практики структурных исследований важны процедуры автоматич. уточнения фаз структурных амплитуд. На основе приближённого набора фаз φ_{hkl} сильнейших структурных амплитуд и по соответствующим экскерим. модулям $|F_{hkl}|$ по (2) вычисляются первое приближённое распределение электронной плотности в кристалле $\rho(x, y, z)$. Затем $\rho(x, y, z)$ модифицируется на основе фаз и кристаллохим. информации о свойствах этого распределения. Напр., во всех точках пространства $\rho(x, y, z) \geq 0$; по модифициров. распределению $\rho(x, y, z)$ путём обращения Фурье вычисляются уточнённые фазы φ_{hkl} и вместе с экскерим. значениями $|F_{hkl}|$ используются для построения следующего приближения $\rho(x, y, z)$ и т. д. После получения достаточно точных значений φ_{hkl} по (2) строится трёхмерное распределение электронной плотности в кристалле. Оно по существу является изображением исследуемой структуры, и вся сложность его получения вызвана отсутствием собирающих линз для рентг. излучения.

Правильность полученной атомной модели проверяют сравнением экскерим. $|F_{hkl}|_{\text{эксп}}$ и вычисленных $|F_{hkl}|_{\text{выч}}$ по (3) модулей структурных амплитуд. Количеств. характеристика такого сравнения — фактор расходимости

$$R = \left(\sum_{hkl} \left| |F_{hkl}|_{\text{эксп}} - |F_{hkl}|_{\text{выч}} \right| \right) / \sum_{hkl} |F_{hkl}|_{\text{выч}}.$$

Этот фактор даёт возможность методом проб и ошибок получить оптим. результаты. Для некристаллич. объектов это практически единств. метод интерпретации дифракц. картины.

Определение фаз структурных амплитуд прямыми методами осложняется при увеличении числа атомов в элементарной ячейке кристалла. Псевдосимметрия и некр-ые др. особенности его строения также ограничивают возможности прямых методов.

Иной подход к определению атомного строения кристаллов по рентг. дифракц. данным был предложен А. Л. Патерсоном (A. L. Patterson). Атомная модель структуры строится на основе анализа ф-ции межатомных векторов $P(u, v, w)$ (ф-ция Патерсона), k -рая вычисляется по экскерим. значениям $|F_{hkl}|^2$. Смысл этой ф-ции можно пояснить с помощью схемы её геом. построения. Атомную структуру, содержащую в элементарной ячейке N атомов, помещаем параллельно самой себе так, чтобы первый атом пошёл в начало координат.

Если упростить атомные веса всех атомов структуры на значение атомного веса первого атома, то получим веса первых N пиков ф-ции межатомных векторов. Это т. н. изображение структуры в первом атоме. Затем в начале координат помещаем таким же образом построенное изображение структуры во втором атоме, затем в третьем и т. д. Прodelав эту процедуру со всеми N атомами структуры, получим N^2 пиков ф-ции Патерсона (рис. 5). Т. к. атомы не являются точками, получающаяся ф-ция $P(u, v, w)$ содержит достаточно размытые и перекрывающиеся пики:

$$P(u, v, w) = V^{-1} \iiint_V \rho(x, y, z) \rho(x-u, y-v, z-w) dv dx dz = \\ = 2V^{-1} \sum_{hkl} |F_{hkl}|^2 \cos 2\pi(hu + kv + lw).$$

$[dv dx dz$ — элемент объёма в окрестности точки (x, y, z)]. Ф-ция межатомных векторов строится по квадратам модулей экскерим. структурных амплитуд и является свёрткой распределения электронной плотности $\rho(x, y, z)$ с собой, но после инверсии в начале координат.

Трудности интерпретации $P(u, v, w)$ связаны с тем, что среди N^2 пиков этой ф-ции необходимо распознать пики одного изображения структуры. Максимумы ф-ции Патерсона существенно перекрываются, что ещё более осложняет её анализ. Наиб. прост для анализа случай, когда исследуемая структура состоит из одного тяжёлого атома и неск. значительно более лёгких атомов. В этом случае изображение структуры в тяжёлом атоме рельефно выступает на фоне остальных пиков $P(u, v, w)$. Разработан ряд методов систематич. анализа ф-ции межатомных векторов. Наиб. эффективными из них являются суперпозиц. методы, когда две или более копий $P(u, v, w)$ в параллельном положении накладываются друг на друга с соответствующими сдвигами. При этом закономерно совпадающие на всех копиях

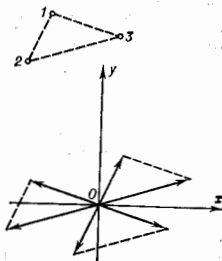


Рис. 5. Схема построения функции межатомных векторов для структуры, состоящей из трех атомов.

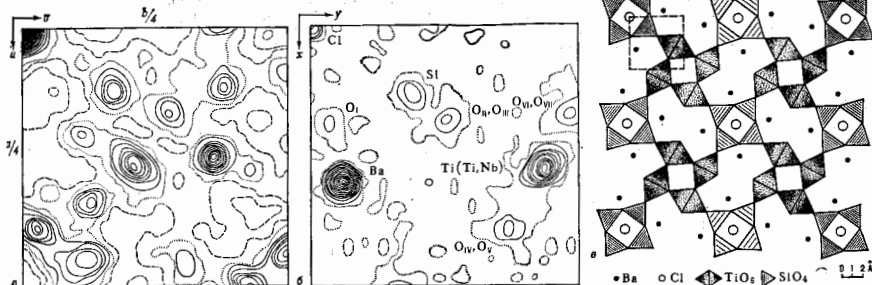


Рис. 6. Минерал боитит $Ba_4Ti_4(Ti,Nb)_2[Si_4O_{12}]_2Cl$; а — функция межатомных векторов, проекция на плоскость ab , линии равного уровня значений функции проведены через равные произвольные интервалы; б — проекция распределения электронной плотности на плоскость ab , полученная путём интерпретации функции межатомных векторов и уточнения атомной модели, ступицами линий равного уровня отмечены положения атомов в структуре; в — проекция атомной модели структуры на плоскость ab в ноллинговских полидрах. Атомы Si расположены внутри тетраэдров из атомов кислорода, атомы Ti и Nb входят в октаэдры из атомов кислорода. Тетраэдры $[SiO_4]$ и октаэдры $[Ti(Nb)O_6]$ в структуре боитита соединены, как показано на рисунке. Атомы Ba и Cl показаны чёрными и светлыми кружками. Часть элементарной ячейки кристалла, изображённая на рисунках а и б, отмечена на рисунке в квадрате, выделенному штриховыми линиями.

пики выделяют одно или несколько из N исходных изображений структуры. Как правило, для единств. изображения структуры приходится использовать до-полнит. копии $P(u, v, w)$. Проблема сводится к поиску необходимых взаимных смещений этих копий. После локализации на суперпозици. синтезе приближённого распределения атомов в структуре атом синтез может быть подвергнут обращению Фурье и т. о. он позволяет получить фазы структурных амплитуд. Последние вместе с эксперим. значениями $|F_{hk}|$ используются для построения $\rho(x, y, z)$. Все процедуры суперпозици. методов алгоритмированы и реализованы в автоматич. режиме на ЭВМ. На рис. 6 изображено атомное строение кристалла, установленное суперпозиционными методами по ф-ции Патерсона.

Разрабатываются эксперим. методы определения фаз структурных амплитуд. Физ. основой этих методов служит эффект Реннигера — многолучевая рентг. дифракция. При наличии одноапр. рентг. дифракц. отражений имеет место перекачка энергии между ними, к-рая зависит от фазовых соотношений между данными дифракц. пучками. Вся картина изменения интенсивности при этом ограничена угл. секундами и для массовых структурных исследований эта методика практич. значения пока не приобрела.

В самостоят. раздел Р. с. а. выделяют прецизионные структурные исследования кристаллов, позволяющие получать по дифракц. данным не только модели атомного строения исследуемых соединений, но и количества. характеристике тепловых колебаний атомов, включая аннотировку этих колебаний (рис. 7) и их отклонения от гармонич. закона, а также пространственное распределение валентных электронов в кристаллах. Последнее важно для исследования связи между атомным строением и физ. свойствами кристаллов. Для прецизионных исследований разрабатываются спец. методы эксперим. измерений и обработки дифракц. данных. В этом случае необходим учёт одноврем. отражений, отклонений от идематичности дифракции, принятие во внимание динамич. поправок теории дифракции и др. тонких эффектов взаимодействия излучения с веществом. При уточнении структурных параметров используются метод ваям. квадратов, причём важнейшее значение имеет учёт корреляции между уточняемыми параметрами.

Р. с. а. используют для установления связи атомного строения с физ. свойствами сегнетоэлектриков,

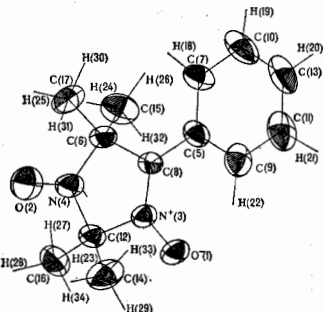


Рис. 7. Эллипсоиды анизотропных тепловых колебаний атомов стабильного нитросильного радикала $C_{11}H_{17}N_3O_2$.

суперионных проводников, лазерных и пелипейшых оптич. материалов, высокотемпературных сверхпроводников и др. Методами Р. с. а. получены уникальные результаты при исследовании механизмов фазовых переходов в твёрдом теле и биол. активности макромолекул. Так, аннотировка поглощения акустич. волн в монокристаллах параллелурита $\alpha-TeO_2$, связанная с ангармонизмом тепловых колебаний атомов Те (рис. 8). Упругие свойства тетрабората лития $Li_2B_4O_7$, открывающие для него перспективы применения в качестве детектора акустич. волн, обусловлены характером хим. связей в этом соединении. С помощью Р. с. а. исследуют распределение в кристалле валентных электронов, реализующих межатомные связи в в.м. Эти связи могут исследоваться с помощью распределения деформаци. электронной плотности, представляющей собой разность

$$\delta\rho(x, y, z) = \rho(x, y, z) - \sum \rho_i(x - x_i, y - y_i, z - z_i),$$

где $\rho(x, y, z)$ — распределение электронной плотности в кристалле, $\sum \rho_i(x - x_i, y - y_i, z - z_i)$ — сумма сфе-

рически симметричных плотностей свободных (не вступивших в хим. связи) атомов данной структуры, к-рые расположены соответственно в точках с координатами x_i, y_i, z_i . При установлении по рентг. дифракц. данным деформац. электронной плотности наиб. сложен учёт

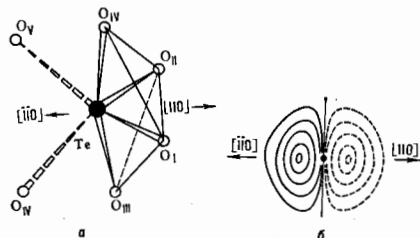


рис. 8. Ближайшее окружение теллура атомами O в структуре SrTeO₆: (а) и алгебраическая составленная распределения плотности вероятности нахождения атома Te в данной точке пространства в процессе тепловых колебаний (б). Положительные (сплошные) и отрицательные (штриховые) линии равного уровня проведены через 0,02 А⁻⁴.

тепловых колебаний атомов, существ. образом коррелирующих с характером и направлениями хим. связей. Т. о., деформац. плотность $\delta\rho(x, y, z)$ отражает перераспределение в пространстве той части электронной плотности атомов, к-рая непосредственно участвует в образовании хим. связей (рис. 9).

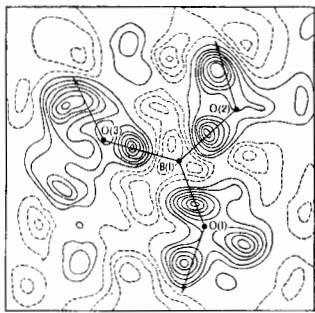


рис. 9. Сечение синтеза деформационной электронной плотности кристалла La₂B₄O₁₂ плоскостью, проходящей через атомы O треугольной группы BO₃, в центре которой находится атом В. Максимумы на отрезках В — O указывают на ковалентный характер связей между этими атомами. Штриховыми линиями выделены области, из которых электронная плотность переместилась на химические связи. Линии равного уровня проведены через 0,2 А⁻⁴.

Структурные исследования высокотемпературных сверхпроводников позволили установить их атомное строение и его связь с их физ. свойствами. Было показано, что в монокристаллах (La,Sr)₂CuO_{4-x} темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние T_c зависит не только от кол-ва Sr, но и от способа его статистич. размещения. Равномерное распределение атомов Sr в структуре является оптимальным для сверхпроводящих свойств. Концентрация Sr в определ. слоях структуры (рис. 10) ведёт к потере в этих слоях части кисло-

рода и к понижению T_c. Для кристаллов YBa₂Cu₃O_{7-x} методами Р. с. а. установлено упорядочение в размещении атомов O. В пределах одного кристалла установлено наличие ромбических по симметрии областей локального состава YBa₂Cu₃O₇ с T_c ~ 90 К и областей

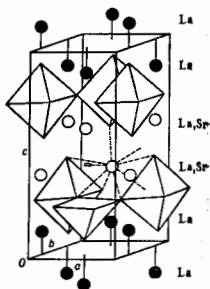


рис. 10. Упорядоченное размещение атомов Sr по нижним лантана в структуре (La,Sr)₂CuO_{4-x}. Атомы Cu находятся в [CuO₄]-октаэдрах. Дефектность по кислороду показана отсутствием у одного из Cu-полиэдров одной кислородной вершины. Позиция, полностью заселённые атомами La, показаны черными кружками. Светлые кружки — позиция лантана, в которых сконцентрированы и статистически размещены все атомы Sr.

YBa₂Cu₃O_{6,5} с T_c ~ 60 К. В кристаллах с кол-вом кислорода меньше чем 6,5 атома на элементарную ячейку, наряду с областями ромбич. симметрии локального состава Ba₂Cu₃O₈ появляются области тетрагональной симметрии локального состава YBa₂Cu₃O₈, к-рые не переходят в сверхпроводящее состояние.

Для решения мн. задач физики твёрдого тела, химии, молекулярной биологии и др. весьма эффективно совместное использование методов рентгеноструктурного анализа и резонансных методов (ЭПР, ЯМР и др.). При исследовании атомного строения белков, нуклеиновых к-т, вирусов и др. объектов молекулярной биологии возникает специфич. сложности. Макромолекулы или более крупные биол. объекты необходимо прежде всего получить в монокристаллич. форме, после чего для их исследования можно применить все методы Р. с. а., развитые для изучения кристаллич. веществ. Проблема фаз структурных амплитуд для белковых кристаллов решается методом изоморфных замещений. Наряду с монокристаллами исследуемого нативного белка получают монокристаллы его производных с тяжелоатомными ионами, изоморфными кристаллам исследуе-

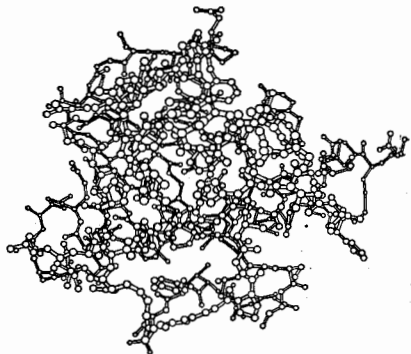


рис. 11. Атомная модель молекулы гуанин-специфичной рибонуклеозиды C_n, построенная на основе рентгеноструктурного исследования монокристаллов этого белка с разрешением 1,55 А.

мого белка. Разностные функции Патерсона для производных и нативного белка дают возможность локализовать в элементарной ячейке кристалла положенные тяжёлыми атомами. Координаты этих атомов и выборы модулей структурных амплитуд белка и его тригемматов для производных используются в спец. алгоритмах для оценки фаз структурных амплитуд. В белковой кристаллографии применяются погашенные методы установления атомного строения макромолекул с последоват. переходом от низкого к более высокому разрешению (рис. 11). Разработаны и спец. методы уточнения атомного строения макромолекул по рентг. дифракц. данным. Объёмы вычислений при этом столь велики, что эффективно могут быть реализованы только на самых мощных ЭВМ.

Вопросы Р. с. а., связанные с изучением реального строения твёрдого тела по дифракц. данным, рассмотрены в ст. *Рентгенография металлов*.

Лит.: Белов Н. В., Структурная кристаллография, М., 1951; Воиный Г. В., Пораян-Кочин М. А., Рентгеноструктурный анализ, 2 изд., т. 1, М., 1964; Янсон Г. Кокрейн В., Определение структуры кристаллов, пер. с англ., М., 1969; Хейл Дж. М., Структура кристаллов и вторичное строение, пер. с англ., М., 1961; Гинье А., Рентгенография кристаллов. Теория и практика, пер. с франц., М., 1961; Стоун Г. Н., Делен Л. Н., X-ray structure determination, N. Y. — L., 1968; Хейл Дж. М., Введение в рентгенометрию монокристаллов, Л., 1973; Бландей Т. Д., Джонсон Л., Кристаллография белка, пер. с англ., М., 1979; Вайнштейн В. К., Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии, М., 1979; Electron and magnetization densities in molecules and crystals, ed. by Becker, N. Y. — L., 1980; Кристаллография и кристаллохимия, М., 1982; Structure and physical properties of crystals, Barcelona, 1981. В. И. Сильнов.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (рентгеновские лучи) — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между УФ- и гамма-излучением в пределах длин волн 10^3 до 10^{-8} м (энергий фотонов $h\nu$ от 10^3 эВ до неск. МэВ; $v = c/\lambda$ — частота излучения). Открыто в 1895 В. К. Рентгеном (W. K. Roentgen). Р. и. с $\lambda < 0,2$ м обладает значит. проникающей способностью и наз. жестким; при $\lambda > 0,2$ м Р. и. сильно поглощается веществом и наз. мягким.

Источники рентгеновского излучения. Наиб. распространённый источник Р. и. — рентг. трубка, в к-рой электроны, вырывающиеся из катода в результате термоэлектронной или автоэлектронной эмиссии, ускоряются электр. полем и бомбардируют металл. анод. Атомы анода, возбуждаемые электронным ударом, и электроны, теряющие кинетич. энергию при торможении в веществе, испускают Р. и. Излучение рентг. трубки наз. первичным и состоит из двух частей: линейчатой (характеристическое Р. и.) и непрерывной (тормозное Р. и.; см. *Рентгеновские спектры*). При действии первичного Р. и. на вещество последнее испускает флуоресценцию (вторичное Р. и., состоящее только из линейчатой части). Если мишень бомбардировать протонами, α -частицами или более тяжёлыми ионами с энергией неск. МэВ на ядро, то мишень будет испускать Р. и. линейчатого спектра с очень слабым непрерывным излучением (контактность характеристич. линий такого Р. и. очень высокая). Для ускорения ионов используют электростатич. генераторы или циклотроны.

В качестве источников Р. и. могут служить также некоторые радиоактивные изотопы; один из них непосредственно испускает Р. и. (напр., атом ^{59}Fe в результате К-захвата превращается в ^{59}Mn и испускает К-спектр Mn), ядра др. радиоактивных элементов (напр., ^{210}Po) испускают электроны или α -частицы, бомбардирующие мишень, в-ра испускает Р. и. Интенсивность излучения изотопных источников на неск. порядков ниже интенсивности излучения рентг. трубки, а их габариты, вес и стоимость значительно меньше, чем у установок с рентг. трубкой.

Излучение рентг. диапазона присутствует и в синхротронном излучении. Это Р. и. можно выделить монохроматором и использовать для разл. целей. Оно на неск. порядков величiny превосходит по интенсивности

излучение рентг. трубки. Ещё более интенсивную рентг. составляющую содержит *орбидаторное излучение*, к-рое на неск. порядков превосходит по интенсивности рентг. составляющую синхротронного излучения; в этих случаях энергия Р. и. столь велика, что кристалл-анализатор, используемый в *рентгеновской спектальной аппаратуре*, нагревается до неск. сотен $^{\circ}\text{C}$ и разрушается, если не приняты спец. меры защиты. Очень высокой интенсивностью обладает также рентг. составляющая *перезодного излучения*. Естественный источник Р. и. — Солнце и др. космич. объекты, в т. ч. Луна, поверхность к-рой бомбардирует частицы высокой энергии, испущенные Солнцем.

Характеристич. Р. и. поликристаллич. анода рентг. трубки распространяется в пространстве изотропно, тогда как распространение тормозного Р. и. анизотропно. При малых напряжениях на рентг. трубке (до 20–30 кВ) тормозное Р. и. имеет макс. интенсивность в направлениях, лежащих в плоскости, перпендикулярной направлению движения электронов, возбуждающих Р. и. При очень высоких напряжениях на рентг. трубке (более неск. сотен тысяч кВ) почти всё излучение распространяется в направлении движения пучка электронов и выходит наружу через пластинку анода. Рентг. составляющая синхротронного излучения поляризована и распространяется только в плоскости кольца синхротрона. Вертикальная расходимость этого излучения очень мала.

Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Существуют два осн. типа взаимодействия Р. и. с веществом: фотоэффект и рассеяние Р. и. При фотоэффекте атом поглощает фотон Р. и. и испускает электрон одной из своих внутр. оболочек. Такое возбуждённое состояние атома неустойчиво, и через 10^{-15} – 10^{-16} с он совершает переход в состояние с меньшей энергией; при этом электрон одной из более удалённых от ядра оболочек заполняет вакансию во внутр. оболочке. Избыток энергии либо испускается в виде рентг. фотона характеристич. излучения атома (излучат. переход), либо атом испускает ещё один электрон (безызлучат. переход, напр. при *ожг-эффекте*) и становится дважды ионизованным. Переход атома в осн. состояние после его внутр. ионизации сопровождается испусканием фотонов характеристич. излучения и ожг-электронов. (О зависимости вероятности поглощения Р. и. от энергии фотонов $h\nu$ и ат. номера Z атома вещества см. в ст. *Рентгеновские спектры*.)

В отличие от поглощения, при рассеянии Р. и. фотоны изменяют направление движения и могут потерять лишь часть своей энергии. При когерентном (упругом) рассеянии Р. и. энергия фотонов не изменяется, но после рассеяния они движутся в др. направлении (*рассеятое рассеяние*). Некогерентное (неупругое) рассеяние с уменьшением энергии фотонов Р. и. может быть двух типов: корпускулярное (см. *Комптона эффект*) и комбинационное. При корпускулярном рассеянии происходит обмен импульсами между электроном атома и фотоном, в результате чего энергия фотона уменьшается на величину, зависящую от угла рассеяния, а из атома вылетает электрон отдачи. При комбинац. рассеянии за счёт части энергии фотона атом испускает электрон. Потеря энергии фотона в этом процессе от угла рассеяния не зависит. Обычно вероятность комбинац. рассеяния значительно меньше вероятности корпускулярного рассеяния; однако если комбинац. рассеяние происходит на одном из электронов Л-оболочки, а энергия фотона совпадает с энергией электронов К-оболочки (с точностью до ширины К-уровня), то наблюдается резонансное комбинационное рассеяние Р. и., вероятность к-рого повышается на неск. порядков величiny и значительно превосходит вероятность корпускулярного рассеяния. В области малых $h\nu$ и Z преобладает когерентное рассеяние, при больших $h\nu$ и Z — некогерентное рассеяние. В результате интерференции когерентно рассеянного

атомами кристалла Р. и наблюдается дифракция рентгеновских лучей — рентг. пучок распадается, возникают дифракц. пучки (в направленных, определенных Брэгга — Вульфа условиях). На этом явлении основан рентгеновский структурный анализ.

Р. и на границе раздела двух сред разл. диэлектрической проницаемости преломляется. Вследствие малости длины волны Р. и показатель преломления вещества в рентг. области спектра очень близок к единице (меньше единицы на $\sim 10^{-5}$ — 10^{-6}). В результате этого фазовая скорость Р. и в веществе превосходит скорость света в вакууме. При точных измерениях углов дифракции Р. и отличие показателя преломления от единицы приводит к усложнению вида условия Брэгга — Вульфа, к-рое установлено в предположении, что зависимость показателя преломления от λ можно пренебречь. Однако вблизи краёв поглощения атомов кристалла-анализатора наблюдаются аномалии а и а д и с п е р с и я, при к-рой отступления от условия Брэгга — Вульфа становятся значительными (см. *Дисперсионная поверхность*). В связи с тем, что для Р. и показатель преломления меньше единицы и вакуум (или воздух) является оптич. наб. плотной средой, при падении рентг. луча под малым углом скольжения на вакуум на гладкую поверхность вещества происходит полное внешнее отражение и исчезает этот луч. С возрастанием угла скольжения оно исчезает при нек-ром критич. значении угла θ_c . С возрастанием λ этот угол увеличивается. На явлении полного внеш. отражения основано устройство рентг. телескопов (см. *Рентгеновская астрономия*) и нек-рых рентгеновских микроскопов. Для отражения Р. и под большими углами (до угла скольжения $\sim 90^\circ$) используют спец. многослойные микроструктуры (зеркала); коэф. отражения такого зеркала достигает неск. десятков процентов.

Применение оптич. линз в рентг. области спектра невозможно вследствие большого поглощения Р. и в материале линз и незначит. отличия показателя преломления от единицы. Для фокусировки Р. и могут быть использованы зонные пластинки (см. *Рентгеновская оптика*). Однако в связи с малыми значениями длины волны Р. и размеры этих пластинок также очень малы (от 20 мкм до неск. мм); число их колец — неск. сотен, расстояние между соседними внеш. кольцами — десятые доли мкм. Такие пластинки изготавливают с помощью рентгеновской литографии.

Рентгеновский интерферометр также отличается от всех видов оптич. интерферометров. Он представляет собой параллелипед из монокристалла Si с двумя углублениями одинаковой ширины, параллельными двум противоположным сторонам параллелепипеда, т. е. образует 3 параллельные пластинки Si на общей основе (в виде буквы Ш), атомные плоскости к-рых строго параллельны, в частности перпендикулярны их поверхностям. Если под углом Брэгга к этим плоскостям направить на ниж. пластинку узкий луч Р. и, то он частично пройдет эту пластинку в осн. направлении, частично дифрагирует в ней, изменяя направление, т. е. первичный луч разделится на два (пластинка наа, д е л и т е л е м л у ч е й). Оба луча затем попадут на ср. пластинку (зеркало) и дифрагируют в ней; на третьей же пластинке (т. д. а и а д и з а т о р е) лучи сойдутся в одну точку. Один из этих лучей проходит через анализатор, не изменяя своего направления, другой — дифрагирует в нём, после чего оба луча получают одно направление, интерферруют один с другим и регистрируются детектором. Если на пути одного из расщепленных лучей поставить пластинку из исследуемого материала, то число длин волн этого луча внутри пластинок изменится, что кажется на числе максимумов интерференции выходящего луча. Таким методом можно измерить отличие показателя преломления от единицы с точностью до 4 значащих цифр. С помощью двух связанных

между собой интерферометров — рентгеновского и *интерферометра Фабри — Перо* было найдено значение 1-й усл. единицы измерения длины волны Р. и. — т. н. Х-единицы ($1 \text{ X} = 1,0020802 \cdot 10^{-4} \text{ нм}$). Рентг. интерферометр позволяет выполнить особо точные измерения параметров кристаллич. структуры, определить малые механич. напряжения в кристаллах, показатели преломления Р. и в разл. веществах.

Для получения рентг. спектров используют дифракцию Р. и от монокристаллов; причём, согласно условию Брэгга — Вульфа, может быть получен рентг. спектр при $\lambda < 2d$ (где d — межплоскостное расстояние; применяемые в рентг. спектроскопии кристаллы имеют разл. значения $2d \leq 2,6 \text{ нм}$; при $\lambda > 2,6 \text{ нм}$ могут быть использованы многослойные микроструктуры, к-рые, однако, обеспечивают лишь сравнительно незначит. разрешение. Дифрагирующим элементом для получения спектров с Р. и в области $1 \text{ \AA} < \lambda < 100 \text{ нм}$ служат дифракционные решётки со скользкими падениями Р. и под углом в неск. градусов. Такие решётки обычно изготавливают нарезанием штрихов профилюров. алмазным резцом, причём число штрихов доходит до 1200 на 1 мм. Резец передвигается от штриха к штриху с помощью прецизионных винтов, что неизбежно накладывает на решётку доплит. периодичность, в результате чего в спектре появляются ложные линии, называемые д $\dot{\chi}$ х а м и. Этого недостатка избегают решётки, изготовленные литографич. методами; с их помощью получают дифракц. решётки с числом штрихов до 6000 на 1 мм.

Характеристик. Р. и рентг. трубки не поляризовано, тормозное — частично поляризовано, причём вблизи квантовой границы его спектра коэф. поляризации приближается к 100%. При дифракции характеристич. Р. и в кристалле возникает поляризация, зависящая от угла Брэгга θ и приближающаяся к 100% при $\theta = 45^\circ$, т. е. когда угол между падающим и дифрагированным лучами равен 90° .

Регистрация рентгеновского излучения. Для регистрации Р. и используют чаще всего спец. рентг. фотоплёнку (см. *Рентгенограммы*). Т. к. жёсткое Р. и обладает значит. проникающей способностью, фотоплёнка содержит новын. кол-во AgBr и выполняется двусторонней. Для определения отношения интенсивностей линий спектра или распределения интенсивностей в дифракц. картинке по их фотоснимку используют микрофотометры и сенситометры, кривую зависимости логарифмич. фотоплотности от интенсивности Р. и. При больших интенсивностях их измеряют с помощью *цифровой камеры*, при средних и малых интенсивностях — с помощью к.-л. пропорционального детектора. Амплитуда регистрируемого сигнала в последних пропорциональна энергии фотона, что позволяет использовать эти приборы в сочетании с многоканальным амплитудным анализатором импульсов в качестве рентг. спектрометров. Для регистрации Р. и служат (цифл.), отнесен. разрешение $\sim 50\%$ (в области $\lambda \approx 0,15 \text{ нм}$), пропорциональные счётчики (отпаянного или проточного типа [при $0,1 \text{ \AA} < \lambda < 10 \text{ нм}$; отнесен. разрешение $\sim 15\%$ (в области $\lambda \approx 0,15 \text{ нм}$), вторично-электронные или каналовые электронные умножители открытого типа с входным фотокатодом (при $\lambda > 1 \text{ нм}$), полупроводниковые детекторы [при $\lambda < 1 \text{ нм}$; кристаллы Si(Li) или Ge(Li), отнесен. разрешение $\sim 2,5\%$ (в области $\lambda \approx 0,15 \text{ нм}$); см. *Детекторы частиц*. Используют также координатно-чувствительные детекторы типа микроканальных пластин или приборов с зарядовой связью, с помощью к-рых линейчатый спектр можно зарегистрировать на ленте самописца в виде записи с правильным отнесен. расположением линий и правильными отнесен. амплитудами этих линий.

Применение рентгеновского излучения. Наиб. широкое использование Р. и. нашло в медицине (для рентгенодиагностики) и рентгенотерапии нек-рых заболе-

ваши), дефектоскопии металлов, наделий и сварных швов, рентгенографии материалов, рентг. структурного анализа (для исследования атомной решетки кристаллов, фазового анализа сплавов, в частности сталей, определения внутр. механич. напряжений, выявления размеров частиц некр-ых материалов, в частности катализаторов с частицами коллоидного размера), в рентгеновской томографии, рентг. микроскопии, спектроскопии твердых тел и молекул, рентгеноспектральном анализе элементного состава материалов (например, поверхности Луны и планет), рентг. астрономии.

Лит.: Хараджа Ф., Общий курс рентгенофизики, 3 изд., М.—Л., 1966; Блохи И. М., Физика рентгеновских лучей, 2 изд., М., 1957; е го же, Методы рентгеноспектрального исследования, М., 1958; Рентгеновские лучи, пер. с нем. и англ., М., 1960; Милрикс Л. И., Рентгеноструктурный анализ. Справочное руководство, М., 1976; Рентгенофизика. Справочник, под ред. В. В. Клыкова, т. 1—2, М., 1980; Блохи И. М., Шт в е й с е р И. Г., Рентгеноспектральный справочник, М., 1982; Рентгеновская оптика и микроскопия, под ред. Г. Шмэйля, Д. Рудольфа, пер. с англ., М., 1987.

М. А. Блохи.

РЕНТГЕНОГРАММА — зарегистрированное на фотопленке (фотопластинке) изображение объекта, возникающее в результате взаимодействия с ним рентг. излучения. При таком взаимодействии могут происходить поглощение, отражение и дифракция рентг. лучей. Пространственное распределение интенсивности излучения после взаимодействия, фиксируемое на Р., отражает строение объекта.

Абсорбционные Р. регистрируют «теневое» изображение объекта, возникающее вследствие неоднородного поглощения рентг. излучения разными участками объекта. Эти Р. применяют в медицине, биологии, дефектоскопии, рентг. микроскопии.

Дифракционные Р. регистрирующие дифракц. рассеяние рентг. излучения образцами, получают в рентг. камерах. Эти Р. используют для решения задач рентгеновского структурного анализа, рентгенографии материалов, рентгеновской томографии. В зависимости от типа исследуемого вещества (поли- или монокристаллы), характера излучения (линейчатый или непрерывный спектры), а также геом. условий съёмки дифракционные Р. разделяют на *дебаевские*, *лауэрамы*, *Р. качения* или *вращения* (получают при качении или вращении образца во время съёмки), *вайсенбергограммы* и *кфорограммы* (получают при синхронном вращении образца и перемещении фотопленки), *коселеграммы* (в широкоотрадиометрической пучке монохроматич. излучения), рентг. топограммы. К дифракционным относятся также Р. *малоуглового рассеяния*, регистрирующие распределение интенсивности рентг. излучения вблизи первичного луча.

Р., фиксирующие распределение интенсивности рентг. излучения, испытывающего полное внеш. отражение от поверхности исследуемого образца, используют в рентг. рефлектометрии для оценки параметров поверхностных слоёв и тонких плёнок.

Р. осуществляется на разл. светочувствит. материалах, выбор к-рых зависит от целей исследования. В том случае, когда Р. не требует дальнейшего оптич. увеличения, съёмка производится на рентгеновскую или полупроводниковую плёнку с невысоким разрешением. Дифракционные и абсорбционные микрорентгенограммы и рентг. топограммы, нуждающиеся в последующем оптич. увеличении, снимают на мелкозернистые фотопленки и пластинки с высоким разрешением.

Е. П. Гостюкова.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ МАТЕРИАЛОВ — область исследований, занимающаяся решением разнообразных задач материаловедения на основе рентг. дифракц. методов (см. Дифракция рентгеновских лучей, Рентгеновский структурный анализ). Р. м. исследует как равновесные, так и неравновесные состояния материалов, изучает их кристаллич. структуру, фазовый состав и его изменения, строит фазовые диаграммы, анализирует состояние деформированных (или под-

вергнутых к.-л. др. воздействиям) материалов, процессы упорядочения и явления ближнего порядка. Р. м. осуществляется с помощью получаемых в рентг. камерах рентгенограмм моно- или поликристаллич. образцов или регистрацией распределения рассеянного рентг. излучения в *рентгеновских дифрактометрах*. Среди методов Р. м. основными являются следующие.

Определение числа, размеров и разориентировки кристаллитов. Размеры кристаллитов поликристаллич. материалов существенно влияют на их механич. свойства. Число N достаточно крупных ($\sim 0,5$ —5 мкм) кристаллитов, участвующих в отражении рентг. лучей, определяется числом n точечных рефлексов, составляющих дебаевское кольцо рентгенограммы (см. Дебаев — Шеррера метод): $N = (2n/\lambda) \cos \theta$, где λ — постоянная величина (параметр аппаратуры), θ — брэгговский угол. Ср. объём кристаллита — отношение объёма образца к N .

Углы разориентировки и размеры блоков мозаичной структуры. Блоки мозаичной структуры — области с правильным строением, поверхности одной относительно другой (разориентированные) на очень малые углы. Углы разориентировки и размеры блоков определяют прочность мозаичных материалов и связаны с плотностью дислокаций. О ср. размерах D блоков мозаики $\sim 0,05$ —1,0 мкм судят по размытию (упирению) дебаевских колец:

$$D = (\lambda/\beta) \cos \theta,$$

где β — полуширина размытой линии. Ср. угол δ разориентировки блоков определяют по эффектам двойного рассеяния рентг. излучения в малоугловой области (при $e = 2\theta \leq 0,5^\circ$), когда первично отражённый луч отражается ещё раз от подходящим образом ориентированного блока в направлении исходного пучка. В окрестности первичного луча появляется дополнит. диффузное рассеяние, интенсивность к-рого $I(e)$ определяется б:

$$I(e) = Ae^{-1} \exp \{-Be^2/\delta^2\},$$

где A и B — пост. величины.

Определение остаточных напряжений. Рентгенография, определение механич. напряжений в простейшем случае сводится к измерению смещения дебаевской линии $\Delta\theta$. При нормальных напряжениях о смещении $\Delta\theta$ связано с σ выражением $\sigma = E \epsilon \sin^2 \theta / \mu$, где E — модуль Юнга, μ — коэф. Пуассона (см. Модуль упругости). Микронапряжения, как и измельчение блоков мозаики, приводят к упирению дебаевских линий. Если упирение обусловлено только микронапряжениями, то их ср. величина (для кристаллов кубич. симметрии) $\Delta\sigma_a = (\beta/4) \epsilon \sin^2 \theta$.

Фазовый анализ. Р. м. позволяет производить качество и количества. Фазовый анализ гетерогенных смесей. Каждая фаза данного вещества даёт на рентгенограмме характерное отражение, что позволяет осуществлять качество. Фазовый анализ. В количестве. Фазовом анализе по отношению интенсивностей отражений определяемой фазы и эталона, находящихся в смеси, судят о концентрации фазы.

Р. м. применяют для исследования изменений в пресыщенном твёрдом растворе, обусловленных его распадом (старением) и, следовательно, возникновением новых фаз и (или) исчезновением старых. Распад твёрдых растворов сопровождается изменением их физ. и механич. свойств. Температурно-временная зависимость концентрации фаз даёт возможность изучать кинетику процессов и выбирать режимы термообработки, установить энергию активации процесса и т. п.

Определение типа твёрдого раствора и границы растворимости. Для установления типа твёрдого раствора определяют кол-во n атомов в элементарной ячейке раствора, используя рентгенографию. данные о её объёме Q и значении плотности раствора ρ : $n = (Q\rho/A) \cdot 1,66 \cdot 10^{-24}$, где A — ср. взвешенная ат.

масса. Сопоставляя n с числом атомов в элементарной ячейке растворителя N , выясняют тип раствора (при $n = N$ — раствор замещения, при $n > N$ — раствор внедрения, при $n < N$ — раствор вытеснения).

Для установления границы растворимости в твердом состоянии анализируют изменения периодов кристаллической решетки при повышении концентрации раствора. Концентрация, при n -ой период решетки (для двухкомпонентных растворов) перестает меняться с дальнейшим изменением состава, означает предельную растворимость для данной температуры. По найденным значениям предельной растворимости для разл. темп-р строят границу растворимости.

Исследование ближнего и дальнего порядков. В твердых растворах атомы компонентов распределены, как правило, не хаотично, а с нек-рой корреляцией (см. *Дальний и ближний порядок*). Когда корреляция существует только в ближайших координац. сферах, возникает либо ближнее упорядочение (напр., в сплавах Fe — Si и Fe — Al), либо ближнее расслоение (в Cr — Mo и Si — Ge). Рентгенографически это можно обнаружить по появлению дополнит. диффузного фона. С помощью Р. м. установлено, что при понижении температуры в твердых растворах с ближним расслоением происходит распад на два твердых раствора (напр., Al — Zn), а в растворах с ближним упорядочением при этом возникает дальний порядок (напр., Fe₃Al).

Измерение диффузного рассеяния рентгеновских лучей позволяет изучать тепловые колебания в кристаллах. Дисперсионные кривые, построенные по рентг. данным, дают возможность определить упругие константы кристалла, вычислить константы межатомного взаимодействия, рассчитать фононный спектр кристалла.

Исследование радиационных повреждений. Р. м. позволяет установить изменения структуры кристаллической решетки под действием проникающей радиации (напр., изменение периодов решетки, возникновение диффузных максимумов), а также исследовать структуру радиоактивных веществ. Дефекты в достаточно крупных и почти совершенных монокристаллах определяют методами рентг. топографии.

Лит.: Уманский Я. С., Рентгенография металлов, М., 1967; его же, Рентгенография металлов и полупроводников, М., 1969; Конобеевский С. Т., Действие облучения на материалы, М., 1967; Уатгер В. В., X-ray diffraction, Reading (Mass.), 1969; Ивернова В. И., Рентгенография, М., 1974; Уманский Я. С., Чириков Н. В., Диффузия и образование фаз, М., 1974; Schulze G. E., Metalphysik, 2 Aufl., В., 1974; Я. С. Уманский, Н. В. Чириков.

РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, возбуждаемая рентгеновским и γ -излучениями; частный случай радиолюминесценции. Р., с помощью k -рой были получены изображения на рентг. экранах, была первым техн. применением люминесценции вообще.

Лит.: Гурвич А. М., Рентгенолюминофоры и рентгеновские экраны, М., 1976.

РЕНТГЕНОМЕТРИЯ — раздел дозиметрии, занимающийся измерением экспозиционных доз рентгеновского и гамма-излучений (с энергией фотонов от 5 кэВ до 5 МэВ) в рентгенах. Р. возникла в 1920-х гг. в связи с развитием практич. применений рентг. излучения в науке, технике, медицине и необходимостью выбора физ. величин и её единиц измерения, характеризующей воздействие рентг. излучения на живые организмы.

На 2-м Междунар. конгрессе радиологов (1928, Стокгольм) было рекомендовано для этой цели применять единицу измерения рентген (Р), определяемую по ионизации воздуха рентг. излучением (воздух был выбран гл. обр. потому, что энергии, поглощаемые 1 г воздуха и 1 г живой ткани, находятся в простом соотношении, почти не зависящем от спектрального состава излучения). Т. к. образование одной пары ионов воздуха требует затраты энергии в 34 эВ, а образование суммар-

ного заряда ионов одного знака, равного единице зарядки СГЭС, соответствует образованию 2,08·10⁸ пар ионов, то энергетич. эквивалент рентгена равен 2,08·10⁸·34 эВ = 0,114 эрг (в 1 см³ воздуха).

Физ. величина, единицей k -рой является рентген, четкое определение получила лишь значительно позднее. Она названа в к с по з и ц и о н н о й д о з о й D_k рентгеновского (или гамма-) излучения: $D_k = \Delta Q / \Delta m$, где ΔQ — суммарный заряд всех ионов одного знака, образующихся в воздухе массой Δm при его облучении рентгеновским (или гамма-) излучением.

В СИ единицей экспозиц. дозы является кулон на килограмм (воздуха): 1 Р = 2,58·10⁻⁴ Кл/кг.

В Р. ионизирующую способность излучения в воздухе измеряют с помощью свободно-воздушных ионизационных камер. В них ионизирующийся объем воздуха окружен слоем воздуха толщиной, равной максимальной свободному пробегу в нём электронов; в результате в ионизационной камере устанавливается т. н. электронное равновесие.

Установлено, что тератич. воздействие рентгеновского и гамма-излучений правильнее связывать не с экспозиц. дозой этого излучения в воздухе, а с поглощенной дозой излучения в тканях организма.

Лит.: Порошков И. В., Рентгенометрия, М.—Д., 1950; М. Ф. Юды, РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — элементный анализ вещества по его рентгеновскому спектру.

Качественный Р. а. выполняют по спектральному положению линий характеристич. спектра исследуемого образца; его основа — *Мозли закон*. Количественный Р. а. осуществляют по интенсивности этих линий. Методы Р. а. могут быть определены все элементы с ат. номерами $Z > 9$ (в нек-рых случаях и более лёгкие).

Наиб. распространено возбуждение рентг. флуоресцентного спектра (вторичного спектра) образца падающим на него первичным излучением рентг. трубки. Предел обнаружения элементов по вторичным флуоресцентным спектрам составляет ~10⁻³—10⁻⁴%; при анализе по третичным спектрам (вторичной флуоресценции), а также при возбуждении рентг. излучения протонами с энергией 1—2 МэВ предел обнаружения элементов снижается до ~10⁻³—10⁻⁴%. Относит. точность количественного Р. а. вдали от предела обнаружения может достигать 1% и менее.

Анализ валового состава по флуоресцентному излучению образцов — высокопроизводительный (весь процесс анализа занимает 5—10 мин) и неразрушающий метод хим. анализа твердых тел. Р. а. производит по одной из наиб. интенсивных линий в спектре анализируемого элемента (т. е. аналитич. линии). Зависимость интенсивности I такой спектральной линии от содержания C_A элемента А в пробе (аналитич. график) может быть построена по стандартным образцам известного состава.

Исследуемая проба состоит из анализируемого элемента и матрицы — всей остальной части пробы. Вид аналитич. графика зависит от поглощ. способности

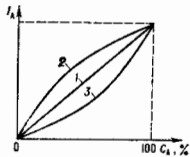


Рис. 1. Аналитический график при различных коэффициентах поглощения матрицы: 1 — $\mu_m < \mu_A$; 2 — $\mu_m = \mu_A$; 3 — $\mu_m > \mu_A$.

матрицы и анализируемого элемента: если они одинаковы, график представляет собой прямую (рис. 1), если матрица поглощает больше (меньше), чем анализируемый элемент, то график — кривая, обращенная выпуклостью вниз (вверх). Интенсивность аналитич.

линия сильно зависит от состава матрицы и гетерогенности пробы (крупность зёрен). Существуют разл. методы преодоления этих трудностей, связанные в осн. со спец. приготовлением пробы.

Один из наиб. растрогранных методов Р. в.— метод внутр. стандарта состоит в том, что в пробу добавляют известное кол-во элемента В, соседнего (по периодич. системе элементов) с анализируемым элементом А. Интенсивность аналитич. линий элементов А и В, расположенных в спектре близко один от другого, с изменением состава матрицы изменяется почти одинаково. Затем строят зависимость отношений интенсивностей линий А и В от отношения их концентраций. Существует также метод, основанный на введении в пробу неск. разл. добавок ΔC_A анализируемого элемента А, построении графика зависимости интенсивности I_A (за вычетом фона) от ΔC_A и экстраполяции его до абсциссы, т. е. до значения $I_A = 0$, для отсчитывания значения $-(\Delta C_A)_0$. Искомое значение $C_A = (\Delta C_A)^0$.

Метод разбавления пробы нейтральной средой заключается в том, что элементом, мало влияющим на интенсивность аналитич. линий, разбавляют пробу в 5—10 раз, тем самым снижая влияние мешающих элементов; его применяют в том случае, когда содержание определяемого элемента достаточно велико.

В лоточном проп-ве часто производят Р. а. на все элементы пробы, для чего служат методы внеш. стандарта, в к-рых по интенсивностям аналитич. линий и соответствующих линий стандартных образцов находят содержание элементов в пробе. Один из таких методов — метод множественной регрессии; в нём для определения концентрации C_M элемента М используют помимо:

$$C_M = a_{M,0} + \sum_Q a_{MQ} I_Q + I_M \sum_{Q \neq M} a'_{MQ} I_Q + \sum_Q a''_{MQ} I_Q^2 + \dots,$$

где I_Q и I_M — интенсивности линий Q-го и M-го элементов пробы. Коэф. $a_{M,0}$, a'_{MQ} , a''_{MQ} определяют по стандартным образцам, число к-рых достигает неск. десятков. Малые члены полинома не учитывают, расчёты осуществляют на ЭВМ. Возможности метода ограничены необходимостью большого числа стандартных образцов и зависимостью коэф. от области концентраций.

Метод теоретич. поправок предполагает аддитивность поправок, вносимых каждым элементом матрицы в интенсивность аналитич. линии. Если интенсивность аналитич. линии элемента А в пробе I_A , а в эталоне $I_{A,эт}$, то в первом приближении концентрация

$$C_A = C_{A,эт} (I_A / I_{A,эт}).$$

В том случае, когда концентрации элемента М в пробе и в эталоне мало отличаются одна от другой ($C_{M,пр} - C_{M,эт} \sim 1\%$), концентрацию C_A находят по ф-ле:

$$C_A = C_{A,0} \left[1 + \sum_M a_{AM} (C_{M,эт} - C_M) \right],$$

где a_{AM} — поправка на элемент М; такие поправки могут быть найдены теоретически для каждой пары АМ элементов. Концентрацию C_A находят с помощью последоват. приближений, в расчётах используют ЭВМ.

В методе фундам. параметров используют точную аналитич. зависимость интенсивности аналитич. линии элемента от осн. физ. параметров пробы, найденную для смешанного характеристич. и тормозного первичного излучения рентг. трубки.

Предел обнаружения концентраций $C_{мин}$ при флуоресцентном Р. а. зависит от ат. номера Z элемента и от серии (K и L), к к-рой принадлежит аналитич. линия (рис. 2). Методы флуоресцентного Р. а. были приме-

нение на обогатит. фабриках цветной металлургии (для экспрессного анализа продуктов флотации, определения меди в шлаках), в чёрной металлургии (для анализа руды, кокса, шлаков, сталей разных марок), на цементных заводах (для анализа сырьевых смесей)

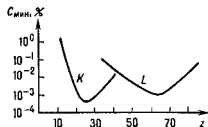


Рис. 2. Зависимость предела обнаружения $C_{мин}$ от атомного номера элемента Z при анализе по линиям K и L-серий.

и т. д. Разработаны также методы Р. а. с возбуждением спектра радиоактивным излучением (рентгено-радиометрич. анализ); соответствующая аппаратура малогабаритна, её вес невелик. Эти методы используют в полевых условиях, с их помощью осуществляют каротаж скважин. Методами флуоресцентного Р. а. определяют состав и толщину тонких плёнок, для чего разработано неск. итерационных методов. Анализ жидкости (напр., нефти на содержание серы) осуществляют по поглощению ею рентг. излучения, к-рое измеряют рентг. фотометром.

Рентгеновский микроанализ (локальный анализ) участков пробы $\sim 1-3$ мкм² выполняется с помощью электронного зонда в микроанализаторе. Электронный зонд формируют с помощью электростатич. и магн. фокусировки до сечения диам. ~ 1 мкм. Анализ осуществляют по рентг. излучению образца, к-рое разлагают в спектре с помощью рентг. спектрометра. В этом методе вводят поправки на Z определяемого элемента, поглощение его излучения в пробе и его флуоресценцию, возбуждаемую тормозной компонентой излучения и характеристик. излучениями др. элементов в пробе. Микроанализ применяют при исследованиях взаимной диффузии 2- и 3-компонентных систем, процессов кристаллизации, локальных флуктуациях состава сплавов и т. д.

Лит.: В о х и м М. А., Методы рентгеноспектрального исследования, М., 1959; Л о с е в Н. Ф., Количественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, М., 1969; П о т о н и к о в Р. И., П ш е н и ч и н ы Г. А., Флуоресцентный рентгенорадиометрический анализ, М., 1973; Физические основы рентгеноспектрального локального анализа, пер. с англ., М., 1975; Электронно-зондовый микроанализ, пер. с англ., М., 1974; А ф о н и н В. П., Г у н и ч е в а Т. Н., Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ горных пород и минералов, Новосибир., 1977; Л о с е в Н. Ф., С м а г у н о в а А. И., Основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, М., 1982; Рентгенофлуоресцентный анализ, под ред. Р. Орхардта, пер. с нем., М., 1985; Б а х т и а р о в А. В., Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ в геологии и геохимии, Л., 1985; Рентгенофлуоресцентный анализ, под ред. Н. Ф. Лосева, Новосибир., 1991. М. А. В о х и м.

РЕНТГЕНСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ — см. Рентгеновский структурный анализ.

РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ (электронная спектроскопия для химического анализа) (РЭС, ЭСХА) — совокупность методов определения строения хим. соединений, состава и структуры поверхности твёрдых тел на основе анализа фотоэлектронов, вылетающих из вещества под воздействием рентг. излучения.

Кинетич. энергия фотоэлектронов $\epsilon_{кин}$ выбитых рентг. квантом $h\nu$ (ν — частота рентг. излучения) с внутр. или внеш. облучек атома, равна

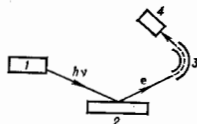
$$\epsilon_{кин} = h\nu - \epsilon_{св},$$

где $\epsilon_{св}$ — энергия связи электрона в атоме и взаимодействиями атома с др. атомами (хим. связь в молекуле и взаимодействием с атомами др. молекул). Т. о., анализ кинетич. энергии вылетающих из вещества электронов позволяет получить информацию об элементном составе образца, распределения хим. элементов по по-

верхности твёрдого тела, характере хим. связей и др. взаимодействий атомов образца.

В электронных спектрометрах (рис. 1), используемых в Р. с., на образец воздействуют излучением рентг.

Рис. 1. Схема электронного спектрометра: 1 — источник излучения; 2 — образец; 3 — электронный энергoанализатор; 4 — детектор.



трубки (обычно линии $AlK\alpha$ или $MgK\alpha$ с энергиями квантов соотв. 1486 и 1254 эВ) или рентг. *синхротронным излучением*. Выбитые электроны попадают в электронный энергoанализатор, к-рый разделяет их по $\Delta\epsilon_{\text{св}}$. Монохроматич. пучки электронов попадают в детектор, измеряющий интенсивность пучков. Т. о. получают рентгеноэлектронный спектр — распределение рентг. фотоэлектронов по их кинетич. энергиям, максимумы в нём — спектральные линии — отвечают определ. атомам (рис. 2); максимумы иногда сдвигаются. Отд. линии обозначают символом элемента,

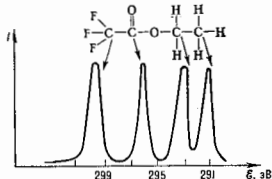


Рис. 2. Рентгеноэлектронный спектр $Ca 1s$ фторидфтористата.

рядом с к-рым указывают уровень энергии фотоэлектрона (напр., линия $Ca 1s$ означает: электроны вылетают с уровня $1s$ углерода).

Р. с. позволяет исследовать все элементы (кроме H) при содержании их в образце $\sim 10^{-5}$ г (пределы обнаружения элемента с помощью РЭС $10^{-7} - 10^{-8}$ г). Относит. содержание элемента может составлять доли процента. Образцы могут быть твёрдыми, жидкими или газообразными.

Величина $\epsilon_{\text{св}}$ электрона внутр. оболочки атома A в хим. соединении определяется эфф. зарядом Z_A этого атома и электростатич. потенциалом U , создаваемым всеми др. атомами соединения:

$$\epsilon_{\text{св}} = kZ_A + U$$

(k — коэф. пропорциональности). Значение $\epsilon_{\text{св}}$ сравнивают с энергией связи аналогичного электрона в стандартном веществе (кристаллич. модификация данного элемента) и вводят понятие хим. сдвига $\Delta\epsilon_{\text{св}}$. Знак $\Delta\epsilon_{\text{св}}$ определяет знак эфф. заряда Z_A атома A в хим. соединениях; значение $\Delta\epsilon_{\text{св}}$ пропорционально Z_A . Поскольку эфф. заряд Z_A зависит от степени окисления атома A, характера соседних атомов и геом. структуры соединения, по $\Delta\epsilon_{\text{св}}$ можно также определять природу функциональных групп, степень окисления атома, способ координации лигандов и т. д.

Энергия связи электронов атомов функциональных групп практически не зависит от типа хим. соединения, в к-ром находится данная функциональная группа. В табл. приведены значения $\epsilon_{\text{св}}$ для нек-рых функциональных групп и лигандов. Относит. интенсивность максимумов, соответствующих разл. функциональным группам (или лигандам), пропорциональна числу таких групп в соединении. Напр., в $Na_2[Fe(CN)_6]$ принадлежность линии $N1s$ групп CN в 5 раз выше, чем линии $N1s$ группы NO, что может быть использовано

Энергия связи электронов центрального атома в некоторых функциональных группах и лигандах

Тип соединения	Уровень энергии	$\epsilon_{\text{св}}$, эВ
RC(O)OH	C1s	289,5
RC(O)OM	—	289,0
R ₂ COH	—	286,7
R ₂ CO	—	288,0
M ₂ CO	—	289-290
Карбиды	—	282-283
Бориды	B1s	188-189
MNO ₂	N1s	408-407
MNO	—	403,8-404,8
RNO ₂	—	406,0
R ₂ N ⁺	—	401-402
NH ₃	—	400,4
MNO ₂	—	298,5
MCN	—	390,2-399
Итриды	—	397-398
M ₂ SO ₄	S2p	169-170
M ₂ SO ₃	—	167-168
Сульфиды	—	161-162
M ₂ PO ₄	P2p	133
—	—	128-130
MClO ₂	Cl2p	206-207
M ₂ O ₄	—	208-209
Хлориды	—	198-200
Силициды	Si2p	99-100

для определения числа разл. функциональных групп (лигандов) в соединении. Значения $\epsilon_{\text{св}}$ в самом лиганде закономерно зависят от особенностей хим. соединения; напр., в случае аниона $\epsilon_{\text{св}}$ его внутр. электронов растёт с увеличением электроотрицательности связанного с ним катона. Хим. сдвиг $\Delta\epsilon_{\text{св}}$ увеличивается с ростом степени окисления атома.

Увеличение (уменьшение) $\epsilon_{\text{св}}$ электронов внутр. оболочек соответствует уменьшению (увеличению) электронной плотности на рассматриваемом атоме. Так, следует ожидать повышения энергии связи электронов в атомах-донорах, поскольку электронная плотность донора смещается к атомам координац. сферы, атом-акцепторы, напротив, принимают часть электронной плотности от центр. атома, вследствие чего $\epsilon_{\text{св}}$ его электронов уменьшается.

Р. с. — один из осн. методов определения состава поверхности, он широко используется при изучении адсорбции, катализа, коррозии и т. д. Применение РЭС для этих целей основано на прямой зависимости интенсивности I_A линий изучаемых атомов A от их концентрации C_A в поверхностном слое толщиной 2-3 нм, сопоставимой с длиной свободного пробега λ электрона в веществе без взаимодействия с др. электронами:

$$I_A = C_A \sigma_A \lambda,$$

где σ_A — сечение фотоионизации с соответствующего уровня энергии, определяющее вероятность ионизации этого уровня в атоме A. Для уровня энергии I атомов A и уровня k атомов B в справедливо соотношение:

$$\frac{C_A}{C_B} = \frac{I_{A0}/\sigma_{A0}\lambda_k}{I_{B0}/\sigma_{B0}\lambda_k^2 k}$$

Величины σ_{A0} , λ_k , σ_{B0} , $\lambda_k^2 k$ можно рассчитать теоретически и на основе измеренных значений I_{A0} . I_{B0} определить C_A/C_B . Надёжнее, однако, измерить отношение I_{A0}/I_{B0} для нескольких известных значений C_A/C_B и экспериментально определить величину пост. множителя ($\sigma_{A0}\lambda_k/\sigma_{B0}\lambda_k^2 k = \text{const}$), а затем определять отношение концентраций по измеренным значениям I_{A0}/I_{B0} . Этот приём наз. методом градуировочных кривых.

Методами РЭС можно установить распределение концентрации элемента по глубине образца, для чего применяют, напр., травление поверхности пучками ионов Ar^+ , Kr^+ . С их помощью в течение 1 мин с поверхности образца удаляется слой толщиной до веск.

десятки нм. Через опрел. промежутки времени проводят рентгеноэлектронный анализ поверхности и получают зависимость интенсивностей опрел. линий от времени травления (или от глубины, если известна скорость травления). Т. о. можно проводить последый анализ на глубину до неск. мкм. Используя зависимость интенсивности линий фотоэлектронного спектра от угла α , определяют изменения состава образца по глубине до 10 нм без его разрушения.

Р. с. — единств. метод, позволяющий определить толщину d и качество монокристаллич. плёнок толщиной 0,5—3,0 нм. Метод основан на экспоненц. зависимости I от d и α :

$$I_A(d) = I_A(0) \exp(-d/\lambda \sin \alpha),$$

где $I_A(d)$ и $I_A(0)$ — интенсивности линий элемента А соответственно при наличии на подложке плёнки толщиной d и без неё; λ — длина свободного пробега фотоэлектронов в плёнке. Для расчёта d достаточно измерить $I_A(d)$ при двух разл. значениях угла α .

Вследствие дифракции фотоэлектронов адсорбиров. молекулы на атомах адсорбента-монокристалла интенсивность рентгеноэлектронного спектра зависит от углов между потоком фотоэлектронов и разл. направлениями в монокристалле. Эта зависимость позволяет определить способ координации адсорбиров. молекулы.

Лит.: Немощкаленко В. В., Алешин В. Г., Электронная спектроскопия кристаллов, 2 изд., К., 1983; М и н а ч е в Х. М., А н т о н о в Г. В., Ш и р о в Е. С., Фотоэлектронная спектроскопия и её применение в анализе, М., 1981; Нефедов В. И., Черепин В. Т., Физические методы исследования поверхности твёрдых тел, М., 1983; Нефедов В. И., Рентгеноэлектронная спектроскопия химической связи, М., 1984.

РЕНТГЕНОЭМУЛЬСИОННАЯ КАМЕРА — координатный детектор частиц высоких энергий, позволяющий определить энергию частицы ($\mathcal{E} \approx 1-2$ ТэВ) и параметры её траектории, используя образование в плотной среде электронно-фотонных каскадов. Последние развиваются в результате процессов тормозного излучения и образования электрон-позитронных пар (см. *Электронно-фотонные цепи*).

Электронно-фотонные каскады регистрируются по суммарному фотогр. действию пучка каскадных электронов на рентг. плёнку, помещённую на нек-рой глубине t в плотном поглотителе (обычно Рb или Fe). При достаточной большой энергии первичной частицы \mathcal{E}_0 и достаточной степени развития каскада число каскадных электронов N на глубине t бывает столь велико (рис. 1), что вызванное ими скрытое изображение после проявления даёт пятно потемнения,

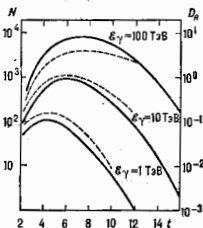


Рис. 1. Каскадные кривые; зависимость числа частиц N (сплошные линии, левая шкала) и интегрального потемнения D_R (пунктирные линии, правая шкала) в круге радиуса $R = 50$ мкм от глубины t в синтетическом поглотителе для различных значений энергии γ -кванта \mathcal{E}_0 .

видимое невооруж. глазом. Размеры пятна определяют и пространственную разрешающую способность Р. к. для регистрации отд. частиц, к-рая в ср. ~ 100 мкм. Видимое пятно потемнения позволяет не только легко обнаружить место прохождения частицы, но и определить \mathcal{E}_0 фотометрированием, т. к. степень его потемнения зависит от числа каскадных электронов, а следовательно и от величины \mathcal{E}_0 .

Количественной мерой потемнения при фотометрировании служит величина $D = \lg I_0/I$, где I_0 и I — ин-

тенсивности светового пучка, проходящего через диафрагму фотометра без пятна потемнения и с ним. Существует неск. методов определения энергии \mathcal{E}_0 по фотометрич. измерениям. Наиб. широко используется интегральное потемнение $D_R(\mathcal{E}_0, t)$ на глубине t , измеренное с помощью круговой диафрагмы радиуса R (шляда применяются диафрагмы с прямоуг. щелью). Связь между D_R и \mathcal{E}_0 определяется свойствами эмульсии, к-рые характеризуются кривой почернения $D(n)$ — зависимостью потемнения малого элемента площади от плотности n электронов, прошедших через этот элемент, и пространственным распределением плотности электронов $n(\mathcal{E}_0, t, r, \varphi)$ в каскаде на глубине t (r — расстояние от оси каскада, φ — азимутальный угол в плоскости, перпендикулярной оси каскада). Интегральное потемнение D_R при вертикальном падении равно:

$$D_R(\mathcal{E}_0, t) = -\lg \left\{ \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R \exp[-\ln 10 D(n(\mathcal{E}_0, t, r, \varphi))] \times r \times dr d\varphi \right\}. \quad (*)$$

Для определения \mathcal{E}_0 экспирим. значения D_R сопоставляются с вычисленными по Ф-ле (*), в к-рой $n(\mathcal{E}_0, t, r, \varphi)$ рассчитывается теоретически, а кривая почернения аппроксимируется Ф-цией $D(n) = D_{\max} [1 - \exp(-ns)]$, где s — зфф. площадь зерна эмульсии, D_{\max} — макс. потемнение, до к-рого может быть засвещена плёнка (при бесконечно большой экспозиции). Т. к. с ростом n при переходе к области насыщения погрешность определения n , а следовательно, и \mathcal{E}_0 резко возрастает, для расширения диапазона измеряемых энергий иногда используют одновременно рентг. плёнки двух типов — большой (1) и малой (2) чувствительности (рис. 2).

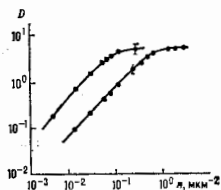


Рис. 2. Кривые почернения для рентгеновских плёнок RT-0M (верхняя кривая) и RT-СШ (нижняя).

В случае $\mathcal{E}_0 \geq 10$ ТэВ при вычислении $n(\mathcal{E}_0, t, r, \varphi)$ следует учитывать влияние многократного рассеяния на сечения осн. процессов (тормозное излучение, образование электрон-позитронных пар), ответственных за развитие каскада в области больших энергий (эффект Ландау — Померанчука — Мигдала). Использование рентг. плёнок для количественных измерений требует введения поправок, учитывающих конструкцию реальных Р. к., стоимость поглотителей, воздушный зазор между Рb и фотоэмульсией и др. Точность определения энергии частиц Р. к. $\sim 15-50\%$.

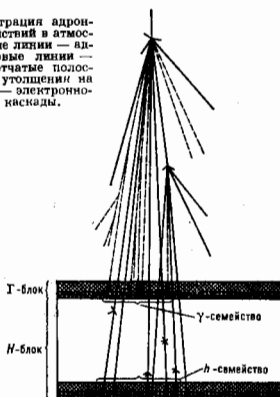
Р. к. помимо энергии частицы позволяет определить угол падения каскада. Рентг. плёнка покрыта с двух сторон слоями эмульсий, разделёнными расстоянием 200—250 мкм, поэтому угол падения можно определить по относит. смещению пятен в эмульсионных слоях. Возможно и использование двух разл. плёнок, разделённых нек-рым промежутком с точным фиксированием их взаимного расположения. Точность измерения азимутного угла $\sim 3^\circ$ и азимутального $\varphi \sim 15^\circ$.

Наряду с интегральным потемнением D_R для определения \mathcal{E}_0 используют сканирование области потемнения фотометрич. ячейкой малого размера с последующей обработкой сканограммы на ЭВМ.

Метод Р. к. позволяет создавать детекторы большой светосилы с высокими пространственным и угловым разрешениями, площадью в сотни и тысячи м^2 и временем непрерывного набора статистики $\sim 1-2$ года. Р. к. применяют в экспериментах с космическими лучами, где интенсивность первичных частиц мала и быстро падает с энергией.

Р. к. можно разделить на 3 типа: Р. к. для регистрации γ -квантов, электронов и позитронов; Р. к. для регистрации адронов; Р. к. для мюонов. Р. к. 1-го типа (т. н. Г-блок) представляют собой свинцовые фильтры, под к-рым помещаются один или неск. слоёв рентг. плёнки. Толщина фильтров подбирается так, чтобы слой плёнок находился вблизи максимума каскадных кривых для изучаемого диапазона энергии (рис. 1).

Рис. 3. Регистрация адронных взаимодействий в атмосфере; сплошные линии — адроны, штриховые линии — γ -кванты; клетчатые полосы — свинец; утолщения на концах линий — электронно-фотонные каскады.



В Р. к. для изучения адронов (Н-блок) включён слой лёгкого вещества (обычно С), в к-ром не происходит заметного развития электронно-фотонного каскада, но адроны испытывают ядерные взаимодействия, а возникающие при этом γ -кванты (в осн. от распада $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$) детектируются в расположенном ниже регистрирующем блоке, аналогичном Г-блоку. Для эфф. регистрации адронов толщина Р. к. должна составлять не менее 1—2 пробегов до взаимодействия, т. е. Р. к. должна быть достаточно глубокой. При исследовании адронных взаимодействий именно служит либо вещество самой Р. к., либо слой плотного вещества, либо слой атмосферы над Р. к. (выбор мипени определяется интервалом изучаемых энергий). В последнем случае обычно используются сочетания Г-блока и расположенного ниже Н-блока (рис. 3). Продукты взаимодействия энергичной частицы с ядром атома воздуха представляют собой смесь заряд. адронов и γ -квантов (с примесью электронов), приходящих практически параллельным пучком к регистрируемым в Р. к. в виде группы пятен потемнения («семейств», рис. 4). Т. к. время экспози-



Рис. 4. «Семейство» четких высокоэнергичных.

ция велико, то в случае необходимости временной селекции «семейств» или др. событий применяется Р. к. в к-рой на одной глубине используются 2 слоя плёнки, один из к-рых через определ. интервалы времени передвигается относительно другого с соответствующей «меткой» времени.

Для регистрации мюонов больших энергий в Р. к. используются γ -кванты тормозного излучения, т. к. в тяжёлом веществе, где $Z^2/A \gg 1$, их испускание — осн. процесс передачи энергии мюона γ -квантам. Тормозное излучение с большой точностью описывается квантовой электродинамикой, поэтому можно уверенно и однозначно переходить от энергии к углу. распределению фотонов к распределению для мюонов. Сечение тормозного излучения мюона мало, поэтому детектор представляет собой глубокую ($\geq 40-60$ см) свинцовую Р. к. с мн. слоями (через 1—2 см) рентг. плёнки. Такно многослойные Р. к. только на снпца служат и для регистрации адронов, однако в этом случае (в отличие от Н-блока со слоем С) объём используемой плёнки и обработки возрастает, хотя информация оказывается более детальной.

Лит.: Аминов В. П. и др., Исследование мюонов сверхвысоких энергий. Метод рентгеномультиплексных камер, М., 1976; Байбурина С. Г. и др., Исследование ядерных взаимодействий в области энергий 10^4-10^6 эВ методом рентгеномультиплексных камер в космических лучах (эксперимент «Алмаз»), «Труды ФИАН», 1984, т. 154, с. 3. В. М. Максимова.

РЕОЛОГИЯ (от греч. rheos — течение и logos — учение) — наука о деформациях и течении реальных сплошных сред (напр., ньютоновских жидкостей со структурной вязкостью, дисперсных систем, обладающих пластичностью). Р. рассматривает процессы, связанные с необратимыми остаточными деформациями вещества (релаксацию напряжений, последствие упругое, ползучесть материалов и т. п.). В основе Р. лежат осн. законы гидромеханики и теории упругости и пластичности (в т. ч. законы И. Ньютона о сопротивлении движению вязкой жидкости, Навье — Стокса уравнения движения несжимаемой вязкой жидкости, Гука закон сопротивления упругого тела и др.).

Р. может рассматриваться как часть механики сплошных сред. В Р. устанавливаются зависимости между действующими на тело механич. напряжениями, вызываемыми ими деформациями и их изменениями во времени. При обычных в механике сплошных сред допущениях об однородности и сплошности материала в теоретич. Р. решают крайние задачи деформирования и течения твёрдых и жидких тел. Осн. внимание обращается на сложное реологич. поведение вещества (напр., когда одновременно проявляются свойства вязкие и упругие или вязкие и пластические). Общее реологич. ур-ние состояния вещества вряд ли может быть установлено из-за сложности различия свойств разнообразных материалов, но имеются ур-ния для многих частных случаев. При описании реологич. поведения материалов пользуются механич. моделями, для к-рых составляют дифференциальные или интегральные ур-ния, куда входят разл. комбинации упругих и вязких характеристик. Реологич. моделими пользуются также при изучении механич. свойств полимеров, внутреннего трения в твёрдых телах и др. свойств реальных тел.

Для одномерных задач служат след. реологич. (механич.) модели: упругий элемент (рис. 1, а) в виде пружины, к-рый отображает упругие свойства; жид-

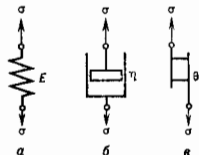


Рис. 1. Механические модели реологических сред: а — упругое тело Гука; б — вязкая жидкость Ньютона; в — жесткоупругое тело Сен-Венана.

костный элемент (рис. 1, б; демпфер, гидравлич. амортизатор), характеризующий вязкие свойства материала. Действующая на упругий элемент сила моделирует напряжение и обозначается σ . Деформация пружины определяет деформацию рассматриваемого реального материала и обозначается ϵ . Жёсткость пружины моделирует модуль упругости E реального материала. Связь между упругой деформацией и напряжением определяется законом Гука: $\sigma = E\epsilon$. Ньютоновская жидкость характеризуется соотношением $\tau = \eta\dot{\epsilon}$ (см. *Ньютона закон трения*).

На рис. 1, в представлена модель жёсткопластич. тела Сен-Венана, изображаемая в виде узла сухого трения. Элементы этого узла (на рис. — вертикальные черточки) смещаются один относительно другого, передавая пост. силу θ , независимую от скорости. Если приложенное напряжение $\sigma < \theta$, смещения нет. Т. о., для тела Сен-Венана деформация ϵ и скорости деформации $\dot{\epsilon}$ равны нулю, пока напряжения σ меньше предела текучести θ ($\sigma < \theta$). При $\sigma = \theta$ начинается деформирование, ϵ и $\dot{\epsilon}$ при этом становятся отличными от нуля. Т. о., элемент сухого трения (рис. 1, в) моделирует предел текучести.

Приведённые элементарные модели обычно рассматриваются в Р. как составные части более сложных механизмов, моделей, отображающих реологию, поведение материала. Для того чтобы построить такие модели, эти элементы соединяют параллельно или последовательно. Так, двухэлементная модель Фойгта (рис. 2) качественно описывает явление упругого пос-

Рис. 2. Механическая модель Фойгта, состоящая из параллельно соединённых пружины E и поршня в цилиндре η , заполненном вязкой жидкостью.

действия, при к-ром деформация равняется с запаздыванием по отношению к приложенному напряжению. Модель Максвелла (рис. 3) удобна для качественного описания процессов релаксации напряжений. Обе эти модели линейны в том смысле, что для них удовлетворяется принцип суперпозиции, но они не обладают достаточной общностью, чтобы определить влияние предистории состояния на поведение тела, т. е. не описывают явление памяти.

Для более точного описания наследств. свойств линейных материалов применяют более сложные модели. Вязкоупругое тело — твёрдое тело,

Рис. 3. Модель Максвелла с последовательным соединением пружины и поршня в цилиндре.

вводящее запаздывающую упругость, можно описывать моделью Кельвина (рис. 4); при деформировании такого тела часть энергии необратимо рассеивается в виде теплоты. Вязкопластичное тело, к-рое не деформируется при напряжениях, меньших некого критич. значения, а при больших — течёт как вязкая жидкость, описывается моделью Бингама (рис. 5), представляющей собой параллельное соединение элементов Ньютона и Сен-Венана.

Течение вязкопластич. тела описывается ур-ниями $\dot{\epsilon} = 0$, $\epsilon = 0$, если $\sigma \leq \theta$, и $\dot{\epsilon} = (\sigma - \theta)/\eta$, если $\sigma > \theta$.

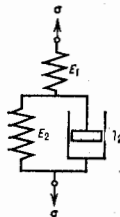


Рис. 4. Модель Кельвина: последовательное соединение элементов Гука и Фойгта.

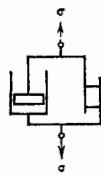


Рис. 5. Модель Бингама: параллельное соединение вязкого элемента (поршень в цилиндре) и тела Сен-Венана.

С проблемами Р. приходится встречаться при разработке технологии разнообразных производств. процессов, при проектных работах и конструкторских расчетах, относящихся к разл. материалам (особенно при высоких темп-рах): полимерам, композиционным материалам, бетонам, силикатам, пищевым продуктам и др. Методы Р. стали применяться для целей оперативного управления технологич. процессами. При этом осуществляются непрерывно или периодически измерение одного или неск. реологич. свойств сырья и (или) продукта по заданной программе, иногда с применением ЭВМ; с использованием обратной связи проводится корректирование в заданных пределах параметров сырья, процесса или дозирование поступающих ингредиентов.

Определяющие соотношения гидродинамики имеют ограниченное применение в Р., поскольку реальные среды обладают аномалией вязкости (напр., вязкость зависит от давления и темп-ры среды, скорости её течения). Проявляется также зависимость напряжённосто-деформированного состояния среды в данный момент времени от всей предистории напряжений (или деформаций). Предметом изучения Р. выступают такие явления, вводящие к аномалии вязкости, как тиксотропия — способность нек-рых дисперсных систем (напр., коагуляц. структур) обратно разжижаться при достаточно интенсивных механич. воздействиях (перемешивании, встряхивании) и отвердевать (терять текучесть) при пребывании в покое; реопексия — ускорение нарастания прочности и структурования дисперсных систем при приложении небольших напряжений и деформировании с небольшой скоростью; дилатация (у концентрированных дисперсных систем тина паст) — возрастание эффективного коэф. вязкости $\eta_{эф} = \tau/\dot{\epsilon}$ (где τ — касат. напряжение, $\dot{\epsilon}$ — скорость деформации сдвига) с увеличением скорости деформирования, сопровождающееся нек-рым увеличением объёма, занимаемого системой (твёрдые частицы при деформировании образуют более рыхлый каркас, и имеющийся жидкой среды оказывается недостаточно, для того чтобы обеспечить системе подвижность).

Экспериментальная Р. (реометрия) определяет разл. реологич. свойства вещества с помощью спец. приборов и испытат. машин. Микрореология исследует деформации и течение в микрообъёмах, напр. в объёмах, сопоставимых с размерами частиц дисперсной фазы в дисперсных системах или с размерами атомов и молекул. Биореология изучает течение разнообразных биол. жидкостей (напр., крови, синовиальной и интервальной жидкостей), деформации разл. тканей (мышц, костей, кровеносных сосудов)

у человека и животных. Изучение взаимоотношения реологии, течения с электр. и магн. полями, к-рые могут воздействовать на потоки как активно, так и путем их влияния на реологию. характеристики вещества, составляет предмет электрореологии и магнитореологии.

Лит.: Реология, пер. с англ., М., 1962; Рейнер М., Реология, пер. с англ., М., 1966; Додж А. С., Эластичные жидкости. Введение в реологию жидкодеформируемых полимеров, пер. с англ., М., 1969; Виноградов Г. В., Малкин А. Я., Реология полимеров, М., 1977; Шульман С. П., Кордонский В. И., Магнитореологический эффект, Минск, 1982; Голдберг Ю. Н., Дарьяевский А. А., Светлов В. В., Физическая кинетика макромолекул, Л., 1886. Н. И. Маличин.

РЕПЛИКА (от лат. *replico* — отражаю, повторяю), 1) в оптике — копия с дифракционной решётки, получаемая изготовлением отпечатка решётки на желатине или спец. пластмассе; 2) в электронной микроскопии — копия-отпечаток (в виде тонкой плёнки углерода, коллодия и др.) поверхности исследуемого объекта, к-рую рассматривают в электронном микроскопе вместо самого объекта.

РЕТРАНСЛЯЦИЯ (от лат. *retranslatio* — приставка, здесь означающая поверхность, и *translatio* — передача) — передача радиосигналов на расстояния, превышающие расстояние прямой видимости, с помощью одного или неск. приёмно-передающих пунктов (ретрансляторов) в пределах зоны прямой видимости отл. пар корреспондирующих пунктов (см. *Загоризонтное распространение радиоволн; Радиорелевые устройства; Радиоприёмные устройства*).

РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ (от лат. *reflecto* — отражаю и греч. *metreo* — измеряю) — совокупность методов исследования плоских границ раздела сред путем анализа зеркально отражённых от изучаемой границы пучков молекул, атомов, частиц или эл.-магн. излучения. Наиб. разработана нейтронная Р., потому в узком смысле Р. — совокупность методов изучения плоских границ раздела сред, в основе к-рых лежит зеркальное отражение пучка инкогерентч. нейтронов ($\leq 10^{-4}$ эВ), падающих под малыми углами скольжения ($\sim 10^{-3}$ — 10^{-2} рад) в плоскости границы. Р. разделяют по типу изучаемых объектов на Р. немагнитных и Р. магнитных сред. В первом случае используются пучки неполяризованных, во втором — поляризованных нейтронов (по Ю. Ризац. Р.). Методами Р. изучают профиль ядерного нейтронно-оптич. потенциала (см. *Нейтронная оптика*) вдоль нормали к границе на глубинах до неск. тысяч ангстрем, а предметом изучения являются поверхности жидкостей, кристаллических или аморфных тел (массивные пластины, тонкие плёнки на подложках), а также внутр. границы в системах жидкость — жидкость, жидкость — твёрдое тело, плёнка — подложка. С помощью поляризац. Р. изучается поведение вектора локальной намагниченности по глубине, в частности особенности магн. свойств приповерхностной (толщиной ≈ 10 А) области ферромагнетиков или идеальных диамангнетиков — сверхпроводников. Объектами изучения в этом случае являются, как правило, массивные пластины или тонкие плёнки на подложках.

Р. получила развитие как один из методов исследования по физике конденсиров. сред на импульсных источниках нейтронов. На рис. 1 и 2 показаны принципиальные схемы рефлектометров по методу времени пролёта. Полихроматич. пучок тепловых нейтронов от импульсного источника, сформированный с помощью поглощающих диафрагм (коллиматоров) 1, 2 (рис. 1), падает на поверхность или внутр. границу раздела образца 3 под углом скольжения $\theta \sim 10^{-3}$ — 10^{-2} рад (угол θ имеет разброс $\Delta\theta/\theta \sim (1-5) \cdot 10^{-4}$). Зеркально отражённые нейтроны регистрируются детектором нейтронов 4 и одновременно анализируются по скорости (длине волны) с помощью электронного устройства (временного анализатора), по времени регистрации, т. е. по времени пролёта нейтроном расстояния от источника до детектора. В поляризац. рефлектометре (рис. 2)

падающий пучок предварительно поляризован с помощью поляризатора нейтронов 1, а образец 6 размещён в зазоре эл.-магн. системы 5 (напр., системы колеб. Гельмгольца), позволяющей создавать на образце магн. поле, изменять его направление и (или) величину.

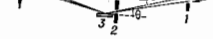


Рис. 1. Схема нейтронного рефлектометра: 1, 2 — диафрагмы; 3 — образец, поверхность которого облучается узкоколлимированным пучком тепловых нейтронов P от источника; 4 — детектор, регистрирующий нейтроны, зеркально отражённые от поверхности образца; θ — угол скольжения. Типичное расстояние от диафрагмы 1 до детектора 6 — 10 м.

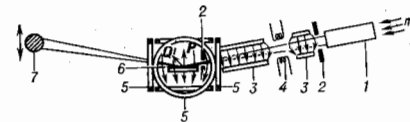


Рис. 2. Схема поляризационного нейтронного рефлектометра: 1 — поляризатор поляризованных тепловых нейтронов; 2 — диафрагмы; 3 — постоянные магниты для адиабатической проводки спина нейтрона; 4 — спин-флиппер, обеспечивающий при включении реверс вектора поляризации P относительно ведущего магнитного поля; 5 — система колеб. Гельмгольца, задающая направление вектора H относительно плоскости образца; 6 — образец; 7 — детектор, регистрирующий зеркально отражённый пучок.

лучину. Эл.-магн. система обеспечивает две важные ф-ции: а) воздействует магн. полем на образец; б) задает определ. направление вектора поляризации P падающих нейтронов относительно поверхности образца. Последнее обеспечивается благодаря адиабатич. проведению спина нейтронов в магн. полях установок. Спец. эл.-магн. устройство — спин-флиппер 4 обеспечивает изменение знака поляризации в падающем пучке. Изменение угла θ производится с помощью механизма поворота образца. Подвижный детектор позволяет измерять как отражённый, так и падающий пучки. Разность координат детектора, соответствующих положениям максимумов прямого и отражённых пучков, позволяет определить угол 2θ с высокой точностью. Совершенствование рефлектометров идёт по пути применения однокоординатных позиционно-чувствит. детекторов нейтронов высокого разрешения ($\Delta x \leq 1$ мм), а также применения многопучкового способа облучения образца, т. е. формирования не одного, а двух или более разнесённых по углу θ узких пучков с раздельной регистрацией каждого из них после отражения.

В Р. результаты измерения представляются в виде коэф. отражения $R(k_z)$ (рис. 3), связанного с интенсив-



Рис. 3. Экспериментальная зависимость коэффициента отражения $R(k_z)$ ($\Delta x = 2\pi/k_z$) от поверхности одного и того же образца стекла (пластина), получаемого излучением на низком оловне; 1, 2 — коэффициенты отражения от поверхности, граничащих с оловом и воздухом соответственно. На вставках: пространственная зависимость потенциалов $U(z)$, обеспечивающая подложку кривых $R(k_z)$. Загнтрированы области шероховатости.

ностями падающего $I_0(k_z)$ и зеркально отражённого $I(k_z)$ пучков соотношением

$$R(k_z) = I(k_z)/I_0(k_z).$$

Здесь k_z — нормальная к границе раздела компонента волнового вектора падающего нейтрона \mathbf{k} ($k_z = k \sin \theta$). Теоретич. интерпретация ф-ции $R(k_z)$ основывается на решении стационарной квантово-механич. задачи об отражении скалярной плоской нейтрон-волны $\exp(ik_z z)$ от границы одномерного потенциала

$$U(z) = -4\pi(\hbar^2/2m)N(z)b(z)$$

[$U(\infty) \sim 10^{-7}$ эВ — типичное значение; $N(z)$, $b(z)$ — локальные (средние по плоскости xy) плотности рассеивающих ядер и их нейтронов для рассеяния]. Т. о., форма потенциала $U(z)$ определяется пространственными (ядоль z) особенностями плотности и состава среды в микроскопич. уровне.

Причины, приводящие к размотно потенциала $U(z)$ в приграничных областях (~ 100 Å), в основном следующие: на поверхности — микрошероховатость, отличие поверхностной плотности от объёмной, примеси; на внутр. межслойных границах, кроме перечисленных, — взаимная диффузия.

Теоретич. значение $R(k_z)$ получают методами численного решения стационарного Шрёдингера уравнения с модельным потенциалом $U(z)$. Для модели полубесконечной среды (массивная пластина) в области $R(k_z) \ll 1$ [$k_z \gg k_0 = (U(\infty)/(\hbar^2/2m))^{1/2}$], где применимо *близкое приближение*, задача имеет аналитическое решение:

$$R(k_z) = R_0(k_z) \int_0^\infty \frac{1}{U(\infty)} \frac{dU(z)}{dz} \exp(ik_z z) dz^2,$$

где $R_0(k_z)$ — коэф. отражения от потенциала с абсолютной резкой границей:

$$R_0(k_z) = |k_z - k'_z|^2 / |k_z + k'_z|^2,$$

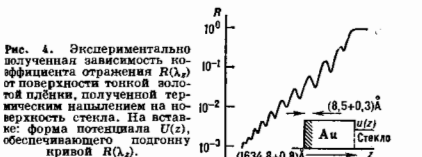
а $k'_z = k_z [1 - U(\infty) \cdot 2m/(\hbar^2 k_z^2)]^{1/2}$ — компонента волнового вектора нейтрона в среде; m — масса нейтрона. Если распределение градиента потенциала является гауссовым (см. Гаусса распределение):

$$\frac{1}{U(\infty)} \frac{dU(z)}{dz} = (1/2\sigma^2) \exp(-z^2/2\sigma^2) \quad (*)$$

(случай шероховатой границы), то при всех $k_z \geq 1/k_0$ коэф. $R(k_z)$ с хорошим приближением описывается ф-лой

$$R(k_z) = R_0(k_z) \exp(-4k_z k'_z \sigma^2).$$

Нижние значения параметра шероховатости σ , извлекаемые из эксперим. значений $R(k_z)$, лежат в области ~ 100 ангстрем. При отражении нейтронов от тонких ($\sim 1000 \div 3000$ Å) плёнок, имеющих потенциал, отличный от потенциала подложки, зависимость R от k_z приобретает осциллирующий характер (рис. 4)



следствие интерференции волн, отражённых от поверхности и от границы с подложкой. В результате средняя по площади толщина плёнки в неск. тысяч Å определяется с точностью в неск. Å.

Ферромагн. среды обладают способностью поляризовать тепловые нейтроны, зеркально отражённые от их поверхности. Это объясняется тем, что потенциал $U_{\mathbf{k}} = -4\pi \mu_{\mathbf{k}} M$ взаимодействия магн. момента нейтрона $\mu_{\mathbf{k}}$ с вектором локальной намагниченности образца M имеет, как правило, значения, сравнимые с нейтронно-оптическим ядерным потенциалом U . Количественной мерой процесса поляризации пучка при зеркальном отражении служит вектор поляризующей способности среды $Q(k_z)$, k -рый задаёт величину и направление поляризации, возникающей в отражённом пучке. Между вектором $Q(k_z)$ и вектором $M_{\perp}(z)$ [проекция вектора $M(z)$ на плоскость xy] имеется взаимно однозначное соответствие, на основе к-рого из $Q(k_z)$ устанавливают распределение $M_{\perp}(z)$. Это позволяет применять поляризац. P в качестве метода изучения структуры намагниченности тонких ферромагн. плёнок с неколлинеарным по глубине осн. состоянием либо возникающим из коллинеарного под действием внеш. магн. поля. Эта возможность — уникальное свойство нейтронной поляризац. P , поскольку др. методы исследования (электропная макроскопия и методы на основе Керра эффекта) не позволяют для таких структур получать полной информации.

В поляризац. P последовательно измеряют интенсивности отражённых пучков: положительно поляризованного $I_+(k_z)$ (спин-флиппер выключён) и отрицательно поляризованного $I_-(k_z)$ (спин-флиппер включён). Знак поляризации пучка задаётся относительно вектора \mathbf{H} ведущего магн. поля установки. Направление \mathbf{H} в месте расположения образца определяет пространственное направление вектора \mathbf{P} поляризации падающего пучка. Величины $I_+(k_z)$ и $I_-(k_z)$ связаны со скалярным произведением векторов \mathbf{P} и $Q(k_z)$ соотношением

$$P \cdot Q(k_z) = \frac{I_+(k_z) - I_-(k_z)}{I_+(k_z) + I_-(k_z)}.$$

Т. о., для определения $Q_{\text{изт}}$ компонент вектора $Q(k_z)$ конкретного образца достаточно измерить $I_{\pm}(k_z)$ для направлений \mathbf{P} вдоль x , y , z осей соответственно.

Поляризац. P используют как прямой метод изучения распределения по глубине диамагн. момента сверхпроводящего образца в приповерхностной области с целью определения лондоновской *слабым проникновением* магн. поля в сверхпроводник, находящийся в междисперской фазе. Формализм описания процесса отражения, служащий для ферромагнетиков, легко переносится на сверхпроводники — идеальные диамагнетики. Для изучения обычных диамагнетиков R не применяется.

Литм.: 1) P e l c h e r G. P. и др., Polarized neutron reflectometer. A new instrument to measure magnetic depth profiles, *J. Rev. Sci. Instrum.*, 1987, т. 58, № 4, p. 609; 2) P e l c h e r G. P. и др., Investigation of magnetism at surfaces by polarized neutron reflection (invited), *J. Appl. Phys.*, 1988, т. 63, № 3, p. 3789; 3) P e n f o l d J., T h o m a s R. K., The application of the specular reflection of neutrons to the study of surface and interfaces, *J. Phys. Condens. Matter*, 1990, т. 2, p. 1369; 4) К о р н е в с е л Л. А., Излучение неупорядоченных магнитных плёнок с помощью поляризованных нейтронов. «Поверхность. Физика, химия, механика», 1989, № 2, с. 13; 5) К о р н е в Д. А., Ч е р н е н к о Л. П., Нейтронная дифракционная оптика ограниченных сред со сложной магнитной структурой, препринт ОИЯИ Р-4—89—709; 6) Г а н о н о в С. В. и др., Определение глубины проникновения магнитного поля в сверхпроводящую тонкую монокристаллическую плёнку $YBa_2Cu_3O_7$ методом отражения поляризованных нейтронов, «Письма в ЖЭТФ», 1989, т. 49, в. 5, с. 277. Д. А. Корнев.

РЕФЛЕКТОР — телескоп, у к-рого объективом является одно вогнутое зеркало (параболическое, гиперболическое или эллиптическое) или система зеркал, включая и плоское. Существует неск. оптич. схем P , к-рые можно взаимно заменять и работать с разными зеркалами.

P . свободны от хроматич. и сферич. aberrаций (см. *Аберрации оптических систем*), что является одним из преимуществ перед рефракторами: повышается светосила и, как следствие, уменьшается длина трубы. В P .

с большим относительным отверстием кома исправлены дуклинновым, почти афокальным корректором, установленным в сходящемся пучке лучей перед гл. фокусом. Д. Д. Максutow выдвигает меньшую телескоп, в к-ром используется *менишковая система*, состоящая из сферич. зеркала (более простого в изготовлении, чем параболическое) и линзы.

К зеркальным поверхностям Р. предъявляются более высокие требования, чем к линзовым; допусаются погрешности одиночного зеркала $\approx 1/8$. Зеркала Р. изготавливают из пирекса, кварца, ситала, нержавеющей стали и др. металлов. Поверхник кружка рассеяния для Р. не должен превышать долей угл. секунды. См. также *Оптический телескоп*.

Лит.: Максutow Д. Д., *Астрономическая оптика*, 2 изд., Л., 1979.

РЕФРАКТОМЕТР (от лат. refractus — преломленный и греч. μέτρον — измеряю) — прибор для измерения показателя преломления n веществ (жидких, твердых, газообразных). Существует неск. видов Р., принцип действия к-рых основан на следующих методах: методе прямого измерения углов преломления света при прохождении им границ раздела двух сред; методе, основанном на явлениях *полюсного внутреннего отражения* (ПВО) света; интерференц. методе (см. *Интерференция света*).

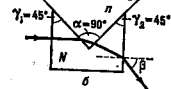
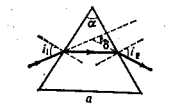


Рис. 1. Схема измерения n по углу преломления.

(рис. 1, б). При $\alpha = 90^\circ$ и $\gamma_1 = \gamma_2 = 45^\circ$ величина n жидкости связана с измеряемым углом выхода β соотношением

$$n = \sqrt{N^2 + \sin^2 \beta} / \sqrt{N^2 - \sin^2 \beta}$$

Точность определения n этим методом $\sim 10^{-5}$, минимальные измеряемые разности n двух веществ $\sim 10^{-7}$.

При использовании для измерения n явления ПВО образец измеряемого материала приводится в оптиче-

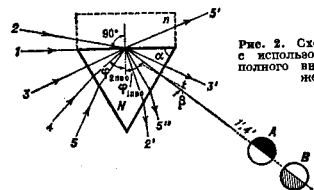


Рис. 2. Схема измерения n с использованием явления полного внутреннего отражения.

ский контакт с эталонной призмой из материала с высоким n и заранее точно известным показателем преломления N (рис. 2). Свет может направляться как со стороны образца, так и со стороны призм. В обоих случаях в определенном и очень узком интервале уг-

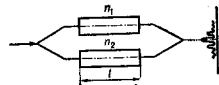
лов падения пучка лучей на границу раздела образца и призмы в поле зрения наблюдательной зрительной трубы появятся граница, разделяющая темный и светлый участки поля и соответствующая предельному, или критическому, углу падения луча: $1 - 1', 2 - 2'$ — ход лучей при освещении со стороны исследуемого образца; $1 - 1' -$ предельный луч, соответствующий углу $\Phi_{\text{пво}}$ в материале призм; $3 - 3', 4 - 4', 5 - 5'$ — ход лучей при освещении со стороны призм; $4 - 4' -$ предельный луч, при падении к-рого под углом $\Phi_{\text{пво}}$ на границу раздела призм и образца происходит ПВО; А и В — схематич. изображения поля зрения наблюдат. труб; n связан с измеряемым углом β между направлением предельного угла и нормалью к грани призм Φ -лой

$$n = \sin \alpha \sqrt{N^2 - \sin^2 \Phi} + \cos \alpha \sin \beta,$$

где α — преломляющий угол призм. Точность метода, использующего ПВО, $\sim 10^{-5}$. Примером Р., основанного на ПВО, является *Аbbe рефрактометр*.

В интерференц. методах разность Δn сравниваемых сред определяют по числу порядков интерференции лучей, прошедших через эти среды. На рис. 3 дана схема, поясняющая принцип действия интерференц. Р.

Рис. 3. Принцип действия интерференционного рефрактометра.



Две части светового луча, проходя через кюветы длиной l , заполненные веществами с различными n , приобретают разность хода Δn , сведенные вместе, дают интерференц. картину (схематически показана справа). Разность $\Delta n = n_2 - n_1 = k\lambda/2$, где λ — длина волны света, k — число интерференц. порядков. Точность этих методов достигает $10^{-7} - 10^{-8}$. Их применяют, напр., при измерениях n газов и разбавленных растворов. Примерами Р., основанных на интерференц. методе, являются *интерферометр Жамена*, *интерферометр Ралей*.

Р. широко применяют в физ. химии для определения состава и структуры вещества, а также для контроля качества и состава разл. продуктов в хим., фармацевтич., пищевой и др. отраслях промышленности. Звонкие градиенты n позволяют производить расчёт градиентов плотности и концентрации. Р. используют при проверке однородности твердых образцов и жидкостей в аэро- и гидродинамич. исследованиях. Особое значение имеют Р. в оптич. промышленности, т. к. n и дисперсия стекла и др. оптич. материалов являются их важнейшими характеристиками.

Лит.: Иоффе В. В., *Рефрактометрические методы химии*, 2 изд., Л., 1974; Шварцловский А. А., *Прикладная физическая оптика*, М., 1961.

РЕФРАКТОМЕТРИЯ — раздел оптич. техники, посвященный методам и средствам измерения показателя преломления n твердых, жидких и газообразных сред в разл. участках спектра оптич. излучения. Приборы для определения n наз. рефрактометрами. О методах Р. см. в ст. *Рефрактометр*.

РЕФРАКЦИЯ ВОЛН — см. *Преломление волн*.
РЕФРАКЦИЯ ЗВУКА (от лат. refractio — преломление) — изменение направления распространения звука в неоднородной среде (атмосфера, океан, толща земли), скорость звука в к-рой является Φ -цией координат. Ход лучей в данном случае определяется уравнением *геометрической акустики*. Звуковые лучи поворачивают всегда к среде с меньшей скоростью звука. Р. з. выражена тем сильнее, чем больше отстоит. градиент скорости звука.

Р. з. в атмосфере обусловлена пространственными изменениями темп-ры воздуха, скорости и направления

ветра. С высотой темп-ра воздуха обычно понижается (до высоты 10—15 км), поэтому скорость звука в верхних слоях воздушной среды меньше, чем в нижних, и лучи от источника звука, находящегося вблизи земной поверхности, загнуты кверху. Звук, начиная с некоего расстояния, перестаёт быть слышим у земной поверхности (зона молчания, или звуковой тени, рис. 1, а). Если темп-ра воздуха с высотой увеличивается (т. е. температурная инверсия, часто возникающая ночью), то лучи поворачивают книзу и звук распространяется на большие расстояния (рис. 1, б). Дальность слышимости при этом может значительно увеличиться за счёт многократных отражений, если звук распространяется над хорошо отражающим участком земной поверхности, напр. над водой (рис. 1, в).

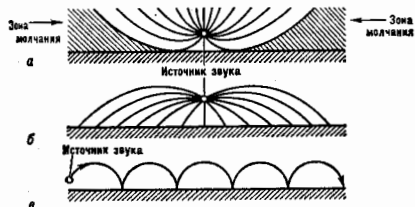


Рис. 1. Ход звуковых лучей: а — при убывании, б — при возрастании температуры с высотой; в — ход луча над хорошо отражающей поверхностью при температурной инверсии.

Приземный слой, в к-ром концентрируется звуковая энергия, является природным *волноводом акустическим*. Повышение темп-ры с высотой в слоях, лежащих выше 20 км, при нормальном её ходе в нижних слоях может привести к образованию зоны аномальной слышимости, расположенной на большем расстоянии от источника звука, чем зона молчания. Может быть неск. следующих друг за другом зон молчания и зон аномальной слышимости.

В приземном слое атмосферы скорость ветра с высотой увеличивается. Поэтому при распространении звука против ветра лучи загнуты кверху, а при распространении по ветру — к земной поверхности, что значительно улучшает слышимость во втором случае (рис. 2). Распределение ветра оказывает также существ.

Рис. 2. Влияние ветра на ход звуковых лучей.



мяние на формирование зон молчания и зон аномальной слышимости.

Р. з. в океане обусловлена пространственными изменениями темп-ры, солёности и гидростатич. давления. Относит. градиенты скорости звука по глубине (максимальные) прибл. в 1000 раз больше, чем в горизонтальном направлении, поэтому горизонтальная Р. з. выражена значительно слабее, чем вертикальная, и может заметно проявиться лишь при распространении звука на очень большие расстояния или в областях сдвижения тёплого и холодного течений, а также в окрестностях айсбергов и зонах внутр. волн и синоптич. вихрей. Вертикальная Р. з. в океане обуславливает ряд явлений: волновое распространение и фокусировка звука, образование зон геом. тени и вторичный выход к поверхности океана звуковых лучей, вы-

шедших из излучателя книзу и распространяющихся первоначально в глубинных слоях (см. *Гидроакустика*). Последнее явление аналогично образованию зон аномальной слышимости в атмосфере.

Лит.: Эмкарт К., Гидродинамика океана и атмосферы, пер. с англ., М., 1953; Акустика океана, под ред. Л. М. Врежовских, М., 1974; Госсард Э., Хук У., Волны в атмосфере, пер. с англ., М., 1978; Врежовских Л. М., Лисаевский Ю. П., Теоретические основы акустики океана, Л., 1982.

РЕФРАКЦИЯ КОНИЧЕСКАЯ — см. *Коническая рефракция*.

РЕФРАКЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ — см. *Молекулярная рефракция*.

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН (преломление радиоволн) — изменение направления распространения радиоволн в неоднородной среде, показатель преломления к-рой зависит от координат и времени. На плоской границе раздела двух однородных сред с показателями преломления n_1 и n_2 плоская волна преломляется по *Снелла закону* преломления $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, где θ_1 — угол падения, θ_2 — угол преломления волны. Амплитуда преломлённой волны зависит от её поляризации и определяется *Френеля формулами* (см. *Отражение радиоволн*).

Наиб. практич. интерес представляют законы Р. р. в неоднородных атмосферах планет и их спутников. Показатели преломления атмосфер непрерывно меняются в пространстве, и траектории радиоволн в них определяются ур-ниями *геометрической оптики*. Существует неск. типов и видов Р. р., к-рые характеризуются местоположением излучателя и приёмника и свойствами среды распространения. При расположении приёмника на поверхности планеты, а излучателя — в атмосфере планеты или за её пределами возможны 3 типа Р. р.: истинная, фотограмметрическая и полная рефракция (соответствующие углы преломления δ , ψ и α , к-рые лежат в вертикальной плоскости, проходящей через излучатель, приёмник и центр планеты). Истинная и фотограмметрич. рефракция определяют соответственно углы, лежащими между прямой «передатчик — приёмник» и касательными к траектории луча в точках излучения и приёма. Полная рефракция характеризуется углом между касательными и траекторией луча в точках расположения излучателя и приёмника. Углы α , δ и ψ связаны между собой простым соотношением $\alpha = \delta + \psi$.

Каждый тип Р. р. делится на неск. видов: оптич. рефракция, радиорефракция, тропосферная, ионосферная, регулярная, случайная, к-рые определяются диапазоном эл.-магн. волн, характером элентрич. свойств среды распространения и её пространственными и временными изменениями. Характер Р. р. в сферически-слоистых атмосферах планет определяется величиной отношения радиуса кривизны траектории луча r к радиусу планеты a_1 : $R_n = \rho/a_1 = -a_1^{-1} (dn/dh)^{-1}$, где dn/dh — высотный градиент показателя преломления атмосферы. Если n уменьшается с высотой ($dn/dh > 0$), то $R_n < 0$. Такая Р. р. наз. положительной, и в этом случае траектории волн обращены вогнутой к планете. Если n растёт с высотой, то $dn/dh < 0$, а $R_n < 0$. Такая Р. р. наз. отрицательной, и в этом случае траектории волн обращены к планете своей выпуклостью. Границей между положительной и отрицательной рефракциями служит прямая линия $R_n = \pm \infty$, к-рая характеризует отсутствие рефракции в однородной атмосфере ($dn/dh = 0$). Положительная Р. р. делится на разл. виды в зависимости от конкретного значения dn/dh и R_n . Так, траектории, для к-рых $R_n = +4$ ($dn/dh = -4 \cdot 10^{-8} \text{ м}^{-1}$), характеризуют нормальную рефракцию, а траектории с $R_n = +1$ ($dn/dh = -15,7 \cdot 10^{-8} \text{ м}^{-1}$) — критическую. Траектории, соответствующие $R_n > 4$, определяют пониженную Р. р., а траектории с $1 < R_n < 4$ — повышенную. Наконец, тра-

ектории, для k -ых $R_{\text{ц}} < 1$, характеризуют с вер- ху ф р а к ц и ю.

Приведенная классификация типов и видов Р. р. соответствует нек-рым ср. условиям изменения показателя преломления с высотой. В реальной атмосфере планеты n меняется с высотой по более сложному закону и, кроме того, зависит от горизонтальных координат. В этом случае искривление траектории волны будет происходить как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости и будет определяться вертикальными и горизонтальными углами Р. р. Эффекты Р. р. в атмосферах планет подробно изучены, и результаты теоретич. и эксперим. исследований широко используются в практич. приложениях, в частности при определении координат естеств. и искусств. излучателей.

Лит.: Колосов М. А., Арманд Н. А., Яковлев О. И., Распространение радиоволн при космической связи, М., 1968; Колосов М. А., Шабельников А. В., Рефракция электромагнитных волн в атмосферах Земли, Венеры и Марса, М., 1976. А. В. Шабельников.

РЕФРАКЦИЯ СВЕТА — изменение направления световых лучей в среде с изменяющимся в пространстве показателем преломления n . Обычно термином «Р. с.» пользуются при описании распространения оптич. излучения в неоднородных средах с плавно меняющимся n от точки к точке (траектории лучей света в таких средах — плавно искривляющиеся линии). Резкое изменение направления лучей на границе раздела двух однородных сред с разными n обычно наз. *преломлением света*. В атм. оптике, очковой оптике траектории используют именно термин рефракция. Т. к. атмосфера является неоднородной средой, то вследствие Р. с. происходит смещение видимого положения небесных светил относительно истинного, что необходимо учитывать в астрономии. Р. с. в атмосфере должна учитываться и при геодезич. измерениях. Р. с. является причиной мirage. Явление Р. с. позволяет визуализировать оптич. неоднородности в твердых, жидких и газовых средах (см., напр., *Гильберт эффект*).

РЕЧЬ в акустике — последовательность звуков речи, произносимых, как правило, слитно, с паузами только после отд. слов или групп звуков. Слитность произношения звуков Р. вследствие непрерывности движений артикуляц. органов Р. вызывает взаимное влияние смежных звуков друг на друга. Артикуляц. органы имеют неодинаковые размеры у разных людей, и для каждого человека характерна своя манера произношения звуков Р., поэтому звуки Р. каждого человека имеют индивидуальный характер. Но при всем многообразии звуков они являются физ. реализациями (произносимым) небольшого числа фонем (наименьшая звуковая единица данного языка, существующая в Р. в целом ряде конкретных звуков). В русской Р. их насчитывается 41: 6 гласных («а», «о», «у», «я», «и», «е», «э»), 2 твердые согласные («ж», «ш», «щ»), 2 мягкие («ч», «ш») и 15 в твердом и мягком видах; звуки Р. «я», «ю», «е», «э» относятся к составным («йа», «йу», «йэ», «йю»).

Звуки Р. неодинаково информативны. Точность передачи Р. (напр., в системах связи) оценивают с помощью артикуляц. метода: передают набор элементов Р. (напр., слов или слогов), отражающий состав звуков Р. данного языка, и определяют относ. кол-во принятых элементов. Разборчивость Р. при этом в значит. мере определяется разборчивостью глухих согласных.

Импульсы потока воздуха, создаваемые голосовыми связками при произношении звуков Р. с достаточной точностью могут считаться периодическими. Соответствующий период колебаний наз. периодом осн. тона голоса, а обратная величина — частотой осн. тона (она лежит обычно в пределах от 70 до 450 Гц). При произнесении звуков Р. частота осн. тона изменяется. Это изменение наз. интонацией. У каждого человека свой диапазон изменения осн. тона (обычно немного более октавы) и своя интонация. Последняя имеет большое значение для узнаваемости голоса. Им-

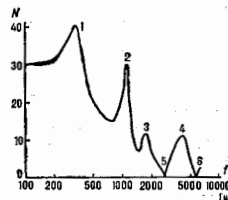
пульсы осн. тона имеют пилообразную форму, а поэтому при их периодич. повторении получается дискретный спектр с большим числом обертонов, или гармоник. При произнесении взрывных и щелевых звуков Р. поток воздуха проталкивается через узкие участки (щели) речевого тракта, поэтому образуются завихрения, создающие шумы с широкополосным сплошным спектром. Т. о., при произнесении Р. через речевой тракт проходит сигнал с тональным, или шумовым, или с тем и др. спектром.

Речевой тракт представляет собой сложную акустич. фильтр с рядом резонансных полостей, создаваемых артикуляц. органами Р., поэтому выходной сигнал, т. е. произносимая Р., имеет спектр с отгибающей сложной водообразной формы (рис.). Максимумы концентрации энергии в спектре звука Р. наз. формантами, а резкие провалы — антиформантами. В речевом тракте для каждого звука Р. есть свои резонансы и антирезонансы, поэтому спектральные отгибающие этого звука имеют индивидуальную форму. Для большинства гласных звуков Р. характерно своё расположение формант и соотношение их уровней; для согласных важен также ход изменения формант во времени (формантные переходы).

Звонкие звуки Р., особенно гласные, имеют высокий уровень интенсивности, глухие — самый низкий. Поэтому при произнесении Р. громкость её непрерывно изменяется, особенно резко при произнесении взрывных звуков. Диапазон уровней Р. находится в пределах 35—45 дБ. Гласные звуки Р. имеют длительность в среднем ок. 0,15 с, согласные — ок. 0,08 с, звук «ш» — ок. 0,03 с.

Образование звуков Р. происходит в результате подачи команд в виде электрич. биосигналов мышцам артикуляц. органов Р. от речевого центра мозга. Этих сигналов не более 10, они изменяются медленно (в темпе смены звуков Р., т. е. от 5 до 20 звуков в секунду), и общий поток их составляет до 100 информ. единиц (бит/с), тогда как весь речевой сигнал имеет поток в 1000 раз больше. Объясняется это тем, что речевой сигнал представляет собой своего рода модуляров. широкополосную несущую (см. *Модуляция колебаний*). Вся информация заключается в спектральной модуляции (в изменении формы отгибающей спектра и уровней Р.), а в самом несущем колебании информация о смысле Р. содержится только в интонации.

Осн. назначение Р. — передача информации от человека к человеку как при их непосредств. общении, так и с помощью средств связи. Т. к. для передачи натуральной Р. требуется пропускная способность канала связи ок. 50 000—70 000 бит/с, то с целью её экономии и соответственно увеличения кол-ва возможных переговоров стремятся сжимать поток речевого сигнала на передающем конце канала с последующим его расширением на приёмном конце. Напр., ослабляя уровень громких звуков Р., уменьшают разность уровней между громкими и слабыми звуками (сжимают динамич. диапазон). Так же можно сжимать частотный диапазон речевого сигнала. Наконец, можно исключить из Р. участки сигнала, не несущие информации (ср. участки длит. звуков), т. е. компрессировать Р. во времени. На приёмном конце соответственно восстанавливают диапазоны и заполняют исключённые участки звуков. Если отделить модулирующий сигнал от несущей, то потребуется ещё меньшая пропускная способность канала связи для передачи Р. По-



добную задачу в системах связи решают т. н. в кодерах.

В совр. исследованиях по общению человека с машиной решаются две проблемы: автоматич. управление машинами и процессами с помощью Р. (устный ввод в ЭВМ, автоматич. пишущая машинка и т. п.) и синтез Р. по разл. кодовым сигналам (устный вывод из ЭВМ, говорящие машины для чтения текста слепым и т. п.).

Исследования механизмов слухового и фонетич. анализа Р. относятся к акустике, психоакустике и фонетике.

Лит.: Сапожков М. А., Речевой сигнал в кибернетике в связи, М., 1963; Файн Г. Г., Акустическая теория речеобразованья, пер. с англ., М., 1968; Файн Г. Г. и Гавин Д. Л., Анализ, синтез и восприятие речи, пер. с англ., М., 1968; Физиология речи. Восприятие речи человеком, Л., 1976. М. А. Спасского.

РЕШЕТКА ВИХРЕЙ АБРИКОСОВА — двумерная решётка квантовых вихрей в сверхпроводниках второго рода (СВР). Теоретически предложена А. А. Абрикосовым (1957) для объяснения магн. свойств СВР. Вихри, образующие Р. в А., характеризуются остовом с радиусом порядка длины когерентности ξ . В центре остова (на оси вихря) плотность сверхпроводящих электронов равна нулю. Вокруг остова на расстояниях порядка глубины проникновения магн. поля λ циркулирует сверхпроводящий ток, распределённый так, что создаваемый им магн. поток равен кванту магн. потока (см. *Квантование магнитного потока*). Схематич. поведение магн. поля и плотности сверхпроводящих электронов изолиров. вихря изображено на рис. 1. В интервале полей $H_{c1} < H < H_{c2}$ (см. *Критическое магнитное поле*) такие вихри в результате взаимодействия

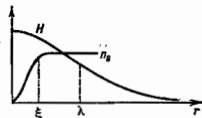


Рис. 1. Распределение плотности сверхпроводящих электронов n и магнитного поля изолированного вихря в зависимости от расстояния до оси вихря r .

друг с другом (отталкивания) образуют регулярную (в однородном материале) решётку. Минимум свободной энергии отвечает треугольная решётка, однако в нек-рых сверхпроводящих материалах, обладающих тетрагональной симметрией, можно наблюдать также квадратную решётку. Характерное расстояние между вихрями определяется приложенным магн. полем. По мере приближения H к H_{c2} остова вихрей сближаются, начинают перекрываться и сверхпроводимость подавляется, пока полностью не разрушится при $H = H_{c2}$. Р. в А. обладает жёсткостью, значения модулей упругости Р. в А. выражаются через параметры кривой намагничивания сверхпроводника. Причиной вихря. сопротивления Р. в А. может нарушаться за счёт дефектов структуры материала, приводящих к лининию вихревых нитей (см. *Критический ток*),

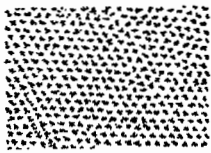


Рис. 2. Воспроизведение структуры решетки Абрикосова в сплаве $Pb - 6,3 \text{ ат. \% In}$, $H \approx 80 \text{ Э}$.

захвату магн. потока в образце и необратимости процесса намагничивания СВР. Р. в А. можно непосредственно наблюдать по рассеянию нейтронов, а также в электронном микроскопе с помощью техники декорирования ферромагн. порошком (рис. 2).

Лит.: Абрикосов А. А., О магнитных свойствах сверхпроводников второй группы, «ЖЭТФ», 1957, т. 32, с. 1442; Сапожков

Жам Д., Сарма Г., Томас В., Сверхпроводимость второго рода, пер. с англ., М., 1970. Н. В. Пономин.

РЕШЕТКИ МЕТОД в квантовой теории поля (КТП) — метод проведения численных вычислений и анализа качественных свойств разл. моделей в осн. в теориях калибровочных полей, включая *квантовую хромодинамику* (КХД), основанный на аппроксимации непрерывного пространства-времени дискретной совокупностью точек — решёткой. Наиб. часто используются кубич. решётка, точки к-рой (наз. узлами) расположены в вершинах кубов, заполняющих пространство. Крайнейшей промежуток между двумя соседними узлами наз. ребром, а длина ребра — шагом решётки.

Простейшим примером КТП на решётке является теория скалярного поля, для к-рой рассматриваются лишь его значения в узлах решётки, а входящие в у-ния движения производные аппроксимируются конечными разностями. Значения полей в узлах решётки являются динамич. переменными задачи. Поскольку во всех практич. приложениях рассматриваются решётки конечного размера, то КТП на решётке превращается в теорию с конечным числом степеней свободы, определяющимся числом узлов. Для удовлетворит. описания непрерывных конфигураций поля необходимо, чтобы шаг решётки был гораздо меньше характерного масштаба изменения полей (в случае гладких конфигураций этого всегда можно добиться, достаточно уменьшив шаг решётки). При решетчатой формулировке спинорового поля его значения также приписываются узлам решётки, в то время как значения *векторного поля* приписываются ребрам.

Для вычисления средних по квантовым флуктуациям полей используется либо гамилтонов метод, когда время остаётся непрерывным, либо евклидова формулировка (см. *Евклидова квантовая теория поля*), для к-рой решётка вводится и по четвёртой оси. Гамильтонов метод даёт возможность описывать пространственно-временную динамику разл. процессов, а евклидова формулировка очень удобна для расчётов стационарных (не зависящих от времени) величин, таких, как массы частиц или потенциалы их взаимодействия, и позволяет воспользоваться для нахождения средних представлением функционального интеграла в КТП (см. *Функциональный интеграл в КТП*).

Возникающие в Р. м. функциональные интегралы можно вычислять аналитически в т. в. области сильной связи, когда шаг решётки гораздо больше, чем характерный масштаб квантовых флуктуаций полей (равный 10^{-13} см для КХД), а не меньше его, как нужно для непрерывного предела. Переход к непрерывному пределу осуществляется путём уменьшения шага решётки. При этом типичные флуктуации становятся распределёнными сразу по многим узлам (для калибровочных полей — по многим ребрам) и возникает задача вычисления интегралов большой кратности, к-рая решается с помощью численного *Монте-Карло метода*.

Поскольку метод Монте-Карло применим лишь к интегралам конечной кратности, рассматривается решётка с конечным числом узлов по каждой из четырёх осей и накладываются, как правило, периодич. граничные условия (т. е. противоположные узлы отождествляются). Как свидетельствуют результаты численных расчётов, в КХД непрерывный предел для глюонных полей наступает довольно рано, когда шаг решётки составляет ок. 10^{-14} см. Это даёт возможность получать относительны к непрерывному пределу результаты уже на решётке протяжённостью 8–10 узлов по каждой оси. Наиб. решётка, к-рая использовалась при численных вычислениях, составляла 32^4 узла, что с учётом спина и цвета глюона приводит к интегралу кратности более $3 \cdot 10^7$.

Решетчатая формулировка КХД была предложена в 1974 К. Г. Вильсоном (К. G. Wilson) в связи с проблемой конфайнмента (мезонизации) кварков (см. *Удёр-*

жание цвета). Каллибровочные теории на решётке об- суджались независимо также Ф. Вегнером (F. Wegner, 1971) и А. М. Подляком (1974). Гамилтонов метод для КХД на решётке разработан Дж. Когутом (J. Kogut) и Л. Саскиндом (L. Susskind) в 1975. Численное изучение свойств решетчатых калибровочных теорий было инициировано работой А. А. Мигдала (1975). Методика вычислений по методу Монте-Карло разработа- на Л. Джейкобсом (L. Jacobs), М. Кройцем (M. Creutz) и К. Ребба (C. Rebbi) в 1979. В основном расчёты методом Монте-Карло в КХД проводились в т. н. приближении валентных кварков, когда пренебрегают рождением из вакуума виртуальных кварк-антикварковых пар. Выполнены также расчёты, к-рые свидетельствуют о том, что учёт виртуальных кварк-антикварковых пар не меняет существенно большинство результатов, полученных в этом приближении.

В приближении валентных кварков было показано (М. Кройц, 1979), что конфайнмент кварков, имеющий место в области сильной связи, остаётся и при уменьшении шага решётки; проводились вычисления зависи- мости потенциала между тяжёлыми кварками от рас- стояния между ними, значения масштабного массового параметра КХД, спектр масс *глюонов* и *конденсатов*, масс разл. мезонов и бариев и нек-рых констант, описы- вающих их распады. Особое место занимают вычисле- ния в КХД при конечной темп-ре, где были рассчитаны значение темп-ры (ок. $2.5 \cdot 10^{12}$ К), при к-рой конфайн- мент исчезает и происходит фазовый переход от др- виков к *кварк-глюонной плазме*; температура зависи- мости плотности энергии системы и её кол-во, погло- щаемое при фазовом переходе, а также значение темп-ры, при к-рой разрушается кварковый конденсат.

Хотя вычисления в КХД методом Монте-Карло значе- ния физ. величин и находятся в согласии с опытом (когда такоо сравнение можно провести), неопределе- нность расчётов пока довольно велика, напр. для масс др- виков она превышает 100 МэВ/с. Ведутся работы, направленные на то, чтобы уменьшить эту неопределе- нность за счёт уменьшения статистич. погрешности, увеличения размера решётки и учёта вклада виртуаль- ных кварков. В частности, создаются процессоры, специ- ально предназначенные для выполнения численных расчётов в КХД.

Лит.: Wilson K. G., Confinement of quarks, «Phys. Rev.», 1974, v. D10, p. 2445; Creutz M., Jacobs L., Rebbi C., Monte-Carlo computations in lattice gauge theories, «Phys. Repts», 1983, v. 95, p. 201; Kogut J., The lattice gauge theory approach to quantum chromodynamics, «Rev. Mod. Phys.», 1983, v. 55, p. 775; Максвелло Ю. М., Метод Монте-Карло в каллибровочных теориях на решётке, «УФН», 1984, т. 143, в. 2, с. 161; Кройц М., Кварки, глюоны и решётки, пер. с англ., М., 1987.

РЕШЕТОЧНАЯ ТЕПЛОЕМОСТЬ — теплоёмкость твёрдого тела, обусловленная атомной подсистемой, в частности кристаллич. решёткой. Р. т. является частью теплоёмкости твёрдого тела. Термин «Р. т.» может относиться не только к идеальным кристаллам, но и к кристаллам с дефектами решётки или примесями, к некристаллич. твёрдым телам (аморфным веществам, стеклам).

Различие между Р. т. при пост. давлении (C_p) и при пост. объёме (C_v) мало: $C_p - C_v \ll C_v$. При $T = 0$ К это является следствием теоремы Нернста (см. *Третье начало термодинамики*), а при произвольных T обусловлено малостью тепловой энергии (kT) относительно энергии связи атомов в твёрдом теле. Величина и тем- пературная зависимость Р. т. C определяются энергетич. спектром (ϵ_j) колебаний атомной подсистемы (см. *Колебания кристаллической решётки*):

$$C = \frac{dQ}{dT} = T \frac{\partial S}{\partial T}, \quad S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V, \\ F = -kT \ln \sum \exp(-\epsilon_j/kT). \quad (1)$$

Здесь S — энтропия, F — Гельмгольцева энергия. Величина $\partial S/\partial T$ вычисляется при пост. давлении либо при пост. объёме, в зависимости от того, какая из величин C_p или C_v подлежит определению.

Спектр колебаний атомной подсистемы зависит от её хим. состава и структуры и для реальных твёрдых тел сложен. Теория Р. т. основана на упрощающих предположениях о виде колебат. спектра. При высоких T , когда возбуждены все $3N$ степеней свободы твёрдого тела, содержащего N атомов, на теоремы о равнорас- пределении энергии следует, что на каждую колебат. степень свободы приходится энергия kT , и потому $C = 3Nk$. Этот результат соответствует эксперим. данным для простых кристаллич. решёток (элементы и простые соединения, см. *Дюлонга и Пти закон*). Для сложных соединений предельное значение $C = 3Nk$ с повышением T обычно не достигается, т. к. раньше происходит их плавление или разложение.

При понижении темп-ры Р. т. убывает, благодаря «вымораживанию» колебаний с энергиями $\epsilon_j \gg kT$. Простейшей моделью, описывающей этот процесс, яв- ляется модель Эйнштейна, в к-рой всем степеням сво- боды твёрдого тела сопоставляются одомодовые гар- монич. осцилляторы с частотой ω_0 . В этом случае

$$C = 3Nk \left(\frac{\theta_0}{2T} \right)^3 \left(\text{sh} \frac{\theta_0}{2T} \right)^{-3}. \quad (2)$$

Величину $\theta_0 = \hbar \omega_0/k$ называют Эйнштейн-ской темп- ратурой.

В области низких T играют роль лишь колебания с малыми энергиями $\epsilon_j \sim kT$, т. е. с малыми частотами $\omega_j = \epsilon_j/\hbar \sim kT/\hbar$. Это звуковые колебания, длина волны к-рых заметно превышает постоянную решётки a при условии $T \ll \hbar u/a$, где u — скорость звука. Число длинноволновых звуковых колебаний в интер- вале частот $d\omega$ в объёме V трёхмерного кристалла равно

$$g(\omega) V d\omega = - \frac{3\omega^2}{2\pi^2} V d\omega, \quad (3)$$

где $\bar{\omega}$ — среднее по различным кристаллографич. на- правлениям, g — плотность распределения колебаний по частотам. С учётом (3) из (1) следует:

$$C = \frac{2\pi^2}{5(\hbar u)^3} k^3 T^3 V. \quad (4)$$

Р. т., пропорциональная T^3 , наблюдается при низких темп-рах для многих твёрдых тел (см. *Дебай закон теплоёмкости*). Этот закон фактически начинает вы- полняться при $T \ll 10$ К для простых решёток и при значительно меньших T для тел со сложной решёткой.

Интерполяция между пределами низких и высоких темп-р в кристаллах даёт *Дебай теорию* твёрдого тела. Она основана на предположении, что частоты рас- пределены по закону (3) на всем протяжении спектра, к-рый образуется при нек-рой максимальной дебайской частоте $\omega_D = u(6\pi^2 N/V)^{1/3}$. При этом соотношение (1) даёт:

$$C = 3Nk \left[D \left(\frac{\theta_D}{T} \right) - \frac{\theta_D}{T} D' \left(\frac{\theta_D}{T} \right) \right], \quad (5)$$

где $\theta_D = \hbar \omega_D/k$ — *Дебай температура*, $D(x) = 3x^{-3} \int_0^x (e^t - 1)^{-1} dt$ — ф-ция Дебая (рис. 1). Критерием применимо- сти этой теории для Р. т. является соотноше- ние T и $\theta_D/4$. Р. т. можно считать постоянной при $T \gg \theta_D/4$ и пропорциональной T^3 при $T \ll \theta_D/4$. Ф-ла (5) пере- даёт ход $C(T)$ лишь для простых решёток; к те- лам с более сложной

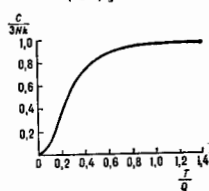


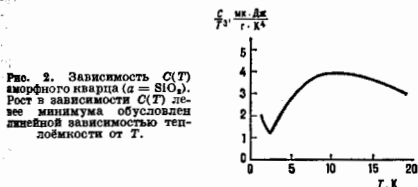
Рис. 1. Зависимость решетоной теплоёмкости от температуры в модели Дебая.

структурой она неприменима, т. к. их спектр колебаний сложен.

В кристаллах «слоистости» или «цепочечности» типа (квазиодномерные соединения и квазидвумерные соединения) спектр звуковых колебаний характеризуется не одной, а несколькими, различными по порядку величины. Закон T^3 для P . т. имеет при этом место лишь при T , малых по сравнению с наименьшей из дебаевских темп-р, в промежуточных же областях T возникают др. законы. Если обозначить через η отношение энергии связи между слоями к энергии связи между атомами в слоях, то закон T^3 для P . т. будет иметь место лишь при $T \ll \eta \theta_D^M$, где θ_D^M — наибольшая из θ_D . В области $\eta \theta_D^M \ll T \ll \eta \theta_D^L$ имеют место зависимости: $C \propto T^2$ для слоистых и $C \propto T^{1/2}$ для цепочечных кристаллов. При $\eta \theta_D^L \ll T \ll \theta_D^M$ имеют место зависимости $C \propto T$ и $C \propto T^{1/2}$.

Влияние дефектов. Величина и температурная зависимость P . т. кристаллов зависит от наличия дефектов и примесей. К увеличению низкотемпературной P . т. при $T \sim \omega_p/k$ могут привести резонансные квазилокальные колебания с частотами $\omega_p \ll \omega_D$, к-рые возникают благодаря введению тяжелых примесей или дефектов. Локальные ВЧ-колебания ($\omega_p > \omega_D$) слабо влияют на P . т. Заметный вклад в низкотемпературную P . т. могут давать также т. н. ориент. дефекты (дислокационные центры) и нецентральные ионы.

Решетчатая теплоемкость некристаллических веществ (аморфных или стеклообразных твердых тел, полимеров, ионных суперпроводников) при низких T кардинально отличается от P . т. кристаллов. При $T < 1$ К P . т. этих веществ существенно превышает P . т. кристаллов и зависит от T приблизительно линейно. При $T \sim 10$ К в зависимости $C(T)$ появляется максимум, свидетельствующий об избыточности (по сравнению с дебаевской) теплоемкости (рис. 2). Такое поведение и ве-



личина P . т. слабо зависит от хим. состава и типа проводимости некристаллич. веществ, являясь в этом смысле универсальными. Так, зависимость $C \propto T$ наблюдается не только в диэлектрических и полупроводниковых *стеклах*, но и в *металлических стеклах*. В последнем случае она экспериментально отделяется от *электронной теплоемкости* по наблюдению и сверхпроводящем состоянии, когда электронная теплоемкость пренебрежимо мала.

Линейная зависимость от темп-ры $C \propto T$ объясняется моделью двухуровневых систем, отвечающих туннельным состояниям атомов в двухъямных потенциалах, существование к-рых связано с неупорядоченностью системы (см. *Неупорядоченные системы*). Постулируется равномерное распределение энергий с плотностью $g(\mathcal{E}) = \text{const}$. Это приводит к соотношению

$$C = \int_0^{\mathcal{E}_{\text{макс}}} d\mathcal{E} g(\mathcal{E}) V \left(\frac{\mathcal{E}}{2kT} \right)^2 \left(\text{ch} \frac{\mathcal{E}}{2kT} \right)^{-2} \approx \frac{\pi}{6} k g V T. \quad (6)$$

Предполагается, что верхняя граница спектра $\mathcal{E}_{\text{макс}} \gg kT$. Тепловое возбуждение двухуровневых систем происходит за время релаксации, величина к-рого

экспоненциально зависит от параметров барьера в двухъямном потенциале. Разброс значений этих параметров в некристаллич. веществе приводит к появлению экзотично широкого спектра времен релаксации. В результате возникает логарифмически слабая зависимость измеряемой P . т. от времени эксперимента.

Лит.: Лангау Я. Д., Ли Флиш и Е. М., *Статистическая физика*, ч. 1, 3 изд., М., 1978; Киттель Ч., *Введение в физику твердого тела*, пер. с англ., М., 1978; *Amorphous solids. Low-temperature properties*, ed. by W. A. Phillips, В. — in. o. l. 1981.

РИГИ — ЛЕДУКА ЭФФЕКТ — заключается во влиянии магн. поля на теплопроводность электронных полупроводников. Открыт практически одновременно в 1887 А. Риги (A. Righi) и С. Ледюком (S. Leduc). Обусловлен, как все *гальваномагнитные явления* и *термогальваномагнитные явления*, искривлением траектории носителей заряда в магн. поле. Для наблюдения P . — Л. в. используют след. геометрию: проводник, в к-ром вдоль осей есть градиент темп-ры $\partial T/\partial x$ и поток тепла $\mathbf{W} = (W, 0, 0)$, помещают в магн. поле $\mathbf{H} = (0, 0, H)$, перпендикулярное \mathbf{W} ; вдоль осей y (перпендикулярно \mathbf{W} и \mathbf{H}) появляется градиент темп-ры

$$\frac{\partial T}{\partial y} = A_{RL} H \frac{\partial T}{\partial x}.$$

Коэф. Риги — Ледюка A_{RL} дается ф-лой (по порядку величин)

$$A_{RL} = \sigma \tau / m c.$$

Здесь τ — время свободного пробега носителей заряда (время релаксации импульса), m — их афф. масса. Для электронов $A_{RL} < 0$, для дырок $A_{RL} > 0$. Существует приближенное соотношение между A_{RL} константой Холла R (см. *Холла эффект*) и уд. проводимостью σ :

$$A_{RL} = \sigma R.$$

Лит.: см. при ст. *Термогальваномагнитные явления*. **РИДБЕРГ** (Ry) — внесистемная единица энергии, применяемая в атомной физике и оптике. Названа в честь Й. Ридберга (J. R. Rydberg). $1 \text{ Р.} = 13,60 \text{ эВ}$, т. е. энергии связи электрона в атоме водорода в основном состоянии (см. *Атом*). $1 \text{ Р.} = 2,1798 \cdot 10^{-18} \text{ эрг} = 1/137$ единицы энергии в *Хартри системе единиц*. **РИДБЕРГА ПОСТОЯННАЯ**, R_∞ — *фундаментальная физическая константа*, входящая в выражения для расчета уровней энергии и частот излучения атомов. Введена Й. Ридбергом (J. R. Rydberg) в 1890. Если принять, что масса атомного ядра бесконечно велика по сравнению с массой электрона (ядро неподвижно), то, согласно квантомеханич. расч.у, $R_\infty = 2\pi^2 m e^4 / c h^3 = 10973731,534(13) \text{ м}^{-1}$ (1986), где e и m — заряд и масса электрона, $R_\infty h c = 13,8065884(10) \text{ эВ}$. При учете движения ядра масса электрона замещается на приведенную массу электрона и ядра; в этом случае $R_1 = R_\infty / (1 + m/M_1)$, где M_1 — масса ядра. **РИДБЕРГОВСКИЕ СОСТОЯНИЯ** — состояния атомов, ионов и молекул с большими значениями главного квантового числа l (высокособужденные состояния). Названы в честь Й. Ридберга (J. R. Rydberg), впервые экспериментально исследовавшего атомные спектры волины границы ионизации [1].

P . с. атомов и ионов характеризуются чрезвычайно малыми (по атомным масштабам) возм. потенциалы, большие временные жизни (т. к. вероятность излучат. квантовых переходов с них мала) и большими радиусами орбит высокособужденного (ридберговского) электрона. P . с. подобны состояниям атома водорода. Переходы между соседними P . с. лежат в радиодиапазоне. Большое значение l позволяет применять для описания P . с. квазиклассич. приближение и использовать для них понятия классич. механики. Большие размеры орбит и малые энергии связи ридберговского электрона обуславливают высокую чувствительность P . с. к воздействию электрич. и магн. полей и большие

эф. сечения взаимодействия атомов в Р. с. с заряженными частицами.

В табл. 1 приведены значения осн. характеристик атомов и атомных ионов, находящихся в Р. с.

Табл. 1.

Физическая величина	Физическая зависимость	Численное значение для $n=100$; $Z=1$
Энергия связи ридберговского электрона:	$Z^2 R_{\infty} / n^2$	$1,36 \cdot 10^{-4}$ эВ
Характерный радиус ридберговской орбиты ¹	$n^2 a_0 / Z$	$0,53 \cdot 10^{-4}$ см
Геометрическое сечение	$\pi a_0^2 n^2 / Z^2$	$0,88 \cdot 10^{-4}$ см ²
Частота переходов между соседними ридберговскими состояниями	$2 R_{\infty} Z^2 / n^3$	$4,13 \cdot 10^7$ с ⁻¹
Радиационное время жизни ридберговского состояния ²	$n^3 (31n - 0,25) / Z^2 A_0$	17 с
Напряженность атомного электрического поля, действующего на ридберговский электрон ³	$E_0 Z^2 / n^4$	$51,4$ В·см ⁻¹
Напряженность электрического поля, соответствующая порогу ионизации атома на ридберговского состояния	$E_0 Z^2 / 16 n^4$	$3,2$ В·см ⁻¹

¹ $R_{\infty} = 1/16 \cdot m e^4 / h^2 \approx 13,6$ эВ — Ридберга постоянная (m, e — масса и заряд электрона), Z — спектральный символ, $a_0 = m^2 c^2 / m e^2 \approx 0,53 \cdot 10^{-4}$ см — Бора радиус. ² $A_0 = 16 \pi^2 R_{\infty} / 3 \sqrt{3} \lambda = -8 \pi^2 / 3 \sqrt{3} \tau_0 = 0,79 \cdot 10^{10}$ с⁻¹, $\tau_0 = m_0 c^2 / h = 4,2 \cdot 10^{-11}$ с — атомная единица времени (m_0 — скорость электрона в атоме водорода). ³ $E_0 = e / a_0 = 5,14 \cdot 10^7$ в. CGSE = $5,14 \cdot 10^7$ В·см⁻¹ — атомная единица напряженности электрич. поля.

Систематич. изучение Р. с. стало возможным с нач. 1970-х гг. благодаря успехам лазерной спектроскопии, позволяющей исследовать в лаб. условиях Р. с. с $l \sim 300$, а также радиоастрономии, т. к. в межзвездных облаках были обнаружены линии поглощения между Р. с. с $n \geq 700$.

Волновые функции и энергия ридберговских состояний атомов. Волновые функции Р. с. с хорошей точностью могут быть представлены как произведение волновых ф-ций ридберговского электрона и оставшейся атомной системы — атомного остатка. Свойства атома в Р. с. в основном определяются волновой ф-цией высоковозбужденного электрона, к-рая является совств. ф-цией гамильтошиана:

$$H_0 = p^2 / 2m + U(r), \quad (1)$$

где $p = i\hbar \nabla$ — оператор импульса, $U(r)$ — потенциальная энергия взаимодействия ридберговского электрона с атомным остатком. При расстояниях r электрона от атомного ядра, много больших размеров атомного остатка, $U(r)$ переходит в кулоновский потенциал: $U(r) = Z e^2 / r$.

Энергии Р. с. изолиров. атома, отсчитанные от границы ионизации, определяются ф-лой Ридберга:

$$\epsilon_{nl} = \frac{R_{\infty} (1 - m/M)}{(n - \delta_l)^2}, \quad (2)$$

где M — масса атомного остатка, δ_l — квантовый дефект, слабо зависящий от n и для орбитального квантового числа $l > 2$ очень быстро уменьшающийся с ростом l . Величины δ_l для S-, P- и D-состояний атомов щелочных металлов приведены в табл. 2.

Вероятности излучат. квантовых переходов атома на Р. с. быстро падают с ростом n и l . Для изолиров. атома в Р. с. с данными l и l' времени жизни $\sim n^3 P$. Если распределение атомов по l термодинамически равновесное $\sim (2l + 1)$, то вероятность $A_{n, n-1}$ излучат. перехо-

Табл. 2.

Серия ридберговского состояния	Li	Na	K	Rb	Cs
$nS_{1/2}$	0,4	1,348	2,18	3,131	4,040
$nP_{1/2}$	0,047	0,855	1,714	2,655	3,592
$nP_{3/2}$	0,047	0,855	1,711	2,641	3,559
$nD_{3/2}$	0,0021	0,0155	0,277	1,347	2,475
$nD_{5/2}$	0,0021	0,0155	0,277	1,347	2,466

дов между Р. с. с n и n' определяется ф-лой Крамерса (с ошибкой не более 20%):

$$A_{n \rightarrow n'} = \frac{2A_0}{n^2} Z^4 \frac{(e e')^{2n}}{e - e'}; \quad e = \frac{e_n}{Z^2 R_{\infty}}; \quad e' = \frac{e_{n'}}{Z^2 R_{\infty}}, \quad (3)$$

где $e_n, e_{n'}$ — энергии уровней, отсчитанные от границы ионизации. Ср. вероятность перехода с данного уровня на все др. уровни энергии есть величина, обратная ср. времени жизни системы на данном уровне.

Ридберговские состояния в электрическом поле принципиально нестационарны — происходит ионизация атома полем. Однако для слабых полей вероятность автоионизации (ионизации полем) экспоненциально мала и Р. с. можно считать квази стационарными. В электрич. поле высоковозбужденные уровни энергии испытывают спарковское расщепление и сдвиг (см. Штарк эффект), их волновые ф-ции являются совств. ф-циями гамильтошиана:

$$H = H_0 + eEr, \quad (4)$$

где H_0 — гамильтошиан (1) атома в отсутствие поля. Если потенциальная энергия $U(r)$ имеет кулоновскую природу (т. е. H_0 — гамильтошиан водородоподобного иона), то ур-ние Шредингера, соответствующее гамильтошиану (4), разделяется в параболич. координатах. Проекция магн. момента на направление поля по-прежнему является интегралом движения. С точностью до второго порядка теории возмущений энергии стационарных состояний, отсчитанная от границы ионизации, дается выражением

$$\epsilon = \left\{ \frac{1}{n^2} - 3n(n_1 - n_2) \frac{F}{F_0} + \frac{1}{8} n^4 [17n^2 - 3(n_1 - n_2)^2 - 9m^2 + 19] \right\} R_{\infty} \quad (5)$$

(n_1, n_2 — параболич. квантовые числа, удовлетворяющие условию: $n_1 + n_2 + 1 = n - m$, m — магн. квант.

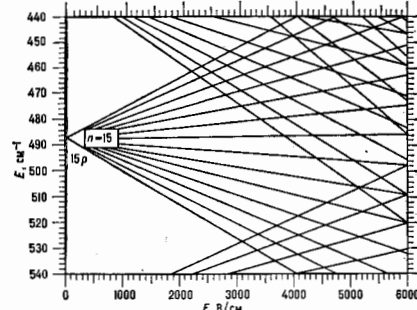


Рис. 1. Схема уровней энергии атома Li в электрическом поле для $n \sim 15$ ($|m| = 1$).

товое число). Выражение k -го порядка теории возмущений приведено в [2]. Ф-ла (5) справедлива и для Р. с. в неводородоподобных атомах, если масштаб штарковского расщепления, определяемый вторым слагаемым, превышает разность энергий между состояниями с разными $l \sim 2d_1 R_{\infty} / n^3$. На рис. 1 в качестве примера приведена схема уровней Li в электрич. поле.

Вероятность ионизации атомов в Р. с. определяется асимптотич. ф-лой [2]:

$$G = \frac{1}{\tau_0} \left(\frac{4E_0}{En^2} \right)^{2n_1+m+1} \times \exp \left[3(n_1-n_2) - \frac{2E_0}{3En^2} \right] \frac{1}{n^2 n_1 (n_1+m)}. \quad (6)$$

Вероятность ионизации атома в Р. с. резко возрастает, когда напряженность электрич. поля E приближается к значению $E_{кр} = E_0/16n^4$, при к-ром возможна автоионизация в рамках классич. механики.

Ридберговские состояния в магнитном поле. В отличие от обычных слабовозбужденных состояний, для к-рых осн. роль играет парамагн. взаимодействие атома с магн. полем (см. *Земана эффект, Пашина — Вака эффект*), для атомов в Р. с. важную роль играет диамагн. взаимодействие, очень быстро растущее с увеличением l . Р. с. в магн. поле описывается гамильтоном:

$$H = H_0 + \mu_B (L + 2S)B + \frac{1}{2} (\mu_B B)^2 \sin^2 \theta, \quad (7)$$

где L и S — полный момент и спин атома соответственно, B — магн. индукция, $\mu_B = eh/2mc$ — магнетон Бора, θ — угол между радиусом-вектором ридберговского электрона и вектором напряженности магн. поля. Второе слагаемое описывает парамагнитное, третье — диамагнитное взаимодействие. Для Р. с. диамагн. взаимодействие растёт $\propto n^4$ и для высоких l становится определяющим. В слабых полях осн. роль играет второе слагаемое, к-рое даёт расщепление по m -компонентам с характерной величиной $\mu_B B$, качество такое же, как и для слабо возбужденных состояний. С ростом напряженности поля увеличивается вклад диамагн. взаимодействия, к-рое связывает состояния с одинаковыми m_l и $\Delta l = 0, \pm 2$. [Для состояний $4p$ ($m = 1$) в атоме водорода диамагн. и парамагн. взаимодействия выравниваются при $B = 2 \cdot 10^7$ Гс. Каждый уровень с квантовыми числами l и m расщепляется на $l - |m|$ компонент. С дальнейшим увеличением напряженности поля начинают перемещаться уровни с разными l и спектр водорода в магн. поле (рис. 2) становится похожим на спектр атома в элек-

трич. поле. В случае предельно сильных полей осн. роль играет взаимодействие с магн. полем и Р. с. являются состояниями Ландау (см. *Ландау уровни*). Кулоновское взаимодействие при этом можно рассматривать как возмущение.

Взаимодействие атомов в ридберговском состоянии с заряженными частицами. Эфф. сечения σ квантовых переходов в атомах, находящихся в Р. с. при столкновениях с заряженными частицами (электронами, ионами), растут как геом. сечение $\sim n^2$. Для переходов с малыми $\Delta l = |l' - l|$ осн. роль играет дальнеедипольное взаимодействие, к-рое приводит к $\sigma \sim \ln^2 n^2 / (\Delta n)^4$, а при больших энергиях внеш. частицы σ зависимость от энергии даётся множителем $(\ln n)^2 / \sigma$ (квантовый логарифм). С ростом Δl всё большую роль начинает играть короткодействующее взаимодействие, позволяющее пренебречь полем атомного остатка в процессе столкновения, а само столкновение рассматривать в рамках классич. механики. Этот подход, называемый классич. бинарным приближением, позволяет получить $\sigma \propto \ln^2 n^2 / (\Delta n)^2$; при больших энергиях $\sigma \propto 1/\epsilon$. В приближении Борна сечение перехода $l \rightarrow n'$ при столкновении с электронами определяется ф-лой (3):

$$\sigma_{n \rightarrow n'} = \frac{\pi a_0^2}{Z n^2} \left(\frac{\pi n'}{\Delta n} \right) \left(\frac{Z^2 R_{\infty}}{\epsilon} \right)^2. \quad (8)$$

Ф-ция \mathcal{F} для $l = 100$ приводится в табл. 3.

Табл. 3.

Δn	$\sqrt{\sigma/\sigma^0}$	1,6	3,2	20	100
1	0,9	1,4	2,75	3,8	
2	0,9	1,3	2,05	2,6	
3	0,9	1,2	1,64	2,0	

Переходы между Р. с. при столкновениях с электронами являются осн. причиной дополнительного (по-мимо доплеровского) неупругого уширения *рекомбинационных радиолний*, наблюдаемых от ряда астрофиз. объектов (планетарных туманностей, межзвёздной среды, зон НII и т. д.).

В столкновении, переходах между Р. с. с одинаковым l осн. роль, как правило, играют ионы. Наиб. велики сечения для переходов между соседними уровнями ($l \rightarrow l \pm 1$), обусловленные дипольным взаимодействием. Они на порядок и более превосходят геом. сечение $(\pi a_0 n^2)$.

Взаимодействие атомов в ридберговском состоянии с нейтральными атомами. Если l достаточно велико, то сечение процесса взаимодействия атомов в Р. с. с нейтральными атомами выражается через амплитуду рассеяния свободного электрона на нейтральном атоме и амплитуду рассеяния атома на положительном заряженном атомном остатке. Напр., в результате взаимодействия с нейтральными атомами Р. с. испытывают уширение γ и сдвиг Δ , пропорциональные концентрации возмущающих частиц N :

$$\gamma = K_\gamma N, \quad \Delta = K_\Delta N;$$

коэф. K_γ , K_Δ выражаются через амплитуду упругого рассеяния электрона на атоме и параметры взаимодействия нейтрального атома с атомным остатком [3] и для достаточно больших l стремятся к константам; в промежуточной области их поведение может быть весьма сложным и зависит от конкретного вида возмущающих частиц. Для атомов Cs в Р. с. возмущающих, напр., атомами Ar, асимптотич. значения $K_\gamma = 5 \cdot 10^{-20} \text{ см}^{-1} \cdot \text{см}^3$, $K_\Delta = 30 \cdot 10^{-20} \text{ см}^{-1} \cdot \text{см}^3$; если возмущающими атомами являются атомы Cs, то K_Δ

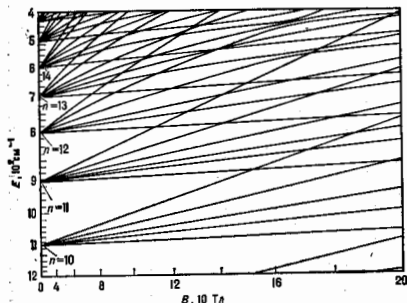


Рис. 2. Схема уровней энергии атома H в ридберговских состояниях в магнитном поле ($m = 1$, чётные состояния).

увеличивается в 20 раз, а K_2 — на 2 порядка. Асимптотич. значеиый коэф. K_1 и K_2 достигают при взаимодействии с атомами инертных газов при $n \approx 20$, а при взаимодействии с атомами щелочных металлов при $n \approx 50$. Поведение сечений др. процессов взаимодействия атомов в Р. с. с нейтральными атомами (перемешивание состояний по l , дезориентация и др.) качественно аналогично поведению сечений ищирения.

Лабораторные эксперименты. Р. с. в лаб. условиях создаются чаще всего возбуждением атома из осн. состояния одним или неск. световыми пучками большой интенсивности (до крайней мере на первом этапе возбуждения —лакачке). Для накачки обычно используются N_2 -лазер или вторая (третья) гармоника лазера на неодимовом стекле. Чтобы получать Р. с. с заданными квантовыми числами n, l, m , на втором этапе атомную систему возбуждают излучением мощных перестраиваемых лазеров на красителях.

Для регистрации Р. с. наиб. распространение получили флуоресцентный метод и метод ионизации электрич. полем. Флуоресцентный метод основан на анализе каскадного испускания света при переходах атома из Р. с. Этот метод обладает селективностью, однако интенсивность регистрируемого излучения в видимой области в этом случае мала. Флуоресцентный метод используют, как правило, для исследования Р. с. с $n \leq 20$.

В методе ионизации электрич. полем регистрируются электроны, освобождающиеся в результате ионизации атома в Р. с. при воздействии на него электрич. поля. В этом случае селективность обеспечивается чрезвычайно резкой зависимостью вероятности ионизации от квантовых чисел n и l . Чаще всего этот метод используется в режиме с временным разрешением: после импульсного возбуждения Р. с. подается пилообразный импульс электрич. поля. Каждое Р. с. в разноразном по времени иониз. сигнале даёт тип через строго определённое время от момента включения поля. Метод отличается простотой, высокой чувствительностью и в отличие от флуоресцентного метода особенно эффективен при исследовании Р. с. с большими n , когда для ионизации не требуется высоких напряжений электрич. поля.

Спектры атомов и ионов в Р. с. исследуются разл. методами. С помощью обычных многомоновдных лазеров достигается спектральное разрешение порядка доплеровской ширины уровня, что позволяет исследовать Р. с. с $n \leq 50$. Если требуется более высокое разрешение, то используют метод скрещенных атомно-лазерных пучков, дающий разрешение в несколько МГц, или методы волновой лазерной спектроскопии. Напр., методом двухфотонной спектроскопии был получен спектр с разрешением порядка КГц. В тех случаях, когда интерес представляют интервалы между соседними Р. с., более удобны методы радиоспектроскопии, квантовых биеий и пересечения уровней (см. Интерференция состояний) [2]. Вместо настройки частоты излучения на частоту перехода между Р. с., на заданную внеш. полем частоту можно настраивать сами Р. с. В этом случае Р. с. позволяют улавливать слабый микроволновый сигнал. Этим методом получена чувствительность $\sim 10^{-17}$ Вт·Гц^{-1/2} в миллиметровом диапазоне; есть основания ожидать повышение чувствительности ещё на 2 порядка.

Особый интерес представляют эксперименты с атомами в Р. с. в резонаторах. Для $n \sim 30$ переходы между Р. с. лежат в миллиметровом диапазоне, для к-рого существуют резонаторы с очень высокой добротностью. То же время влияние электрич. поля на атомы в Р. с. более значительно, чем, напр., для молекулярных вращат. уровней энергии, поэтому с помощью Р. с. впервые удалось продемонстрировать ряд эффектов квантовой электродинамики, предсказанных в 50—60-е гг.: подавление спонтанного радиац. перехода в резонаторе, нутацию Раби — взаимодействие с полем

одного фотона в резонаторе, кооперативные эффекты Дикке для неск. атомов (см. Сверхизлучение) и др. [4]. Астрофизические приложения ридберговских состояний. Первые наблюдения излучат. переходов между Р. с. от астрофиз. объектов (линии 90а и 104а) были выполнены в СССР [5]. Радиолинии излучения, соответствующие переходам между Р. с., наблюдаются вилоте до $l \sim 300$ от галактич. зон Н II, планетарных туманностей, центральных областей пашей Галактики и век-рых др. галактик. Обнаружены также линии Н α , Н β , Н γ , С II. Осн. механизм образования Р. с. в астрофиз. объектах является фоторекомбинация, поэтому радиолинии излучения наз. также рекомбинац. радиолиниями. Радиолинии между Р. с. играют важную роль в диагностике астрофиз. объектов. Для $n < 100$ ширина таких линий обусловлена эффектом Доплера и позволяет судить о ионной темп-ре носият. плазмы. Для более высоких n в ширине может вклад стелкновения с электронами, и т. о. по ширине радиолиний можно оценить также плотность электронов. Отношение интенсивностей радиолиний и континуума даёт электронную темп-ру.

В межзвёздных облаках обнаружены радиолинии поглощения, принадлежащие иону С II и соответствующие переходам между Р. с. с $n > 700$.

Лит.: 1) Rydberg J. R., «Z. Phys. Chem.», 1890, Bd 5, S. 227; 2) Ридберговские состояния атомов и молекул, пер. с англ., М., 1985; 3) Вайнштейн Л. А., Соболев Я. И., Юков Е. А., Возбуждение атомов и ищирение спектральных линий, М., 1978; 4) Hargreaves S., Raymond J. M., «Adv. in Atom. and Molec. Phys.», 1985, v. 20, p. 347; 5) Сорочанко Р. Л., Рекомбинационные радиолинии, в кн.: Физика космоса, 2 изд., М., 1986.

Ридберговские состояния молекул. Высоковозбуждённые электронные состояния M , так же как и атомные, подобны серии состояний иона водорода. Ридберговские орбитали молекул обозначаются главными n и орбитальными l квантовыми числами и типом симметрии группы симметрии молекулы (напр., $1s^2_1$, $1p^2_1$). Энергия Р. с. (отсчитываемая от границы ионизации молекулы) определяется ф-лой Ридберга (2). Для молекулы, состоящей из атомов первого периода, величина квантового дефекта b для nd -орбитали очень мала ($\approx 0,1$), для np -орбитали несколько выше (0,3—0,5), а для ns -орбитали значительно больше (0,9—1,2). Стабильность Р. с. молекул зависит от стабильности осн. состояния или низлежащего возбуждённого состояния молекулярного иона, получается при удалении ридберговского электрона, т. е. ридберговская орбиталь, вообще говоря, является несвязывающей. Стабильность иона зависит от того, удаляется ли электрон со связывающей, разрыхляющей или несвязывающей молекулярной орбитали осн. состояния нейтральной молекулы. Напр., для H_2O из занятых молекулярных орбиталей в осн. состоянии самой верхней является несвязывающая молекулярная орбиталь $1b_1$. Поэтому осн. состояние иона H_2O^+ , получающегося при удалении электрона с этой орбитали, столь же стабильно, как и осн. состояние молекулы H_2O : практически все Р. с. молекулы H_2O , сходящиеся к осн. состоянию иона H_2O^+ , стабильны.

Если электрон переходит с низлежащей на более высокую молекулярную орбиталь с тем же n , то получается состояние наз. с убр д р и д б е р г о в с к и м. Т. к. l не является вполне определённым квантовым числом для низких молекулярных орбиталей, субридберговские состояния мало отличаются от Р. с. молекул, хотя субридберговские орбитали могут быть и связывающими.

Р. с. молекул отличаются от Р. с. атомов гл. обр. благодаря колебаниям, вращениям и возможности диссоциации ионного остова молекулы. Если ионный остов находится в возбуждённом колебат. состоянии, то ридберговский электрон при проникновении в ионный остов (что происходит довольно редко, с вероятностью $\sim 10^{-3}$) может испустить неупругое столкновение с остовом, приобрести достаточную кинетич. энергию за счёт

колебат. энергии остова и привести к ионизации молекулы, наз. колебательной автокионизацией. Процесс автокионизации возможен также за счёт вращения. Высоковозбуждённые Р. с. молекул обычно лежат так близко, что энергетич. интервал между ними бывает такого же порядка или даже меньше, чем квант колебат. или вращат. энергии молекулы. Поэтому часто разделение электронного и ядерного движений, принятое в приближении Борна — Општейнера, для молекул в Р. с. становится непригодным.

Лит.: Герцберг Г., Электронные спектры и строение многоатомных молекул, пер. с англ., М., 1969; Ридбергские состояния атомов и молекул, под ред. Р. Стеббинса, Ф. Даньяля, пер. с англ., М., 1985.

РИМАНА ВОЛНЫ — нелинейные волны в гиперболич. системах вида

$$(v_i)_t + \sum_{j=1}^n a_{ij}(v_k)(v_j)_x + b_i(v_k) = 0, \quad (1)$$

где v_i — набор n вещественных переменных; коэффициенты a_{ij} и b_i могут не только зависеть от переменных v_k , но также явно зависеть от x и t . Система (1) является гиперболической, если ур-ние для характеристик скоростей, $\det(a_{ij} - c\delta_{ij}) = 0$, имеет n веществ. корней $c^{(i)}$, $i = 1, \dots, n$. Каждой характеристич. скорости соответствует характеристика на плоскости (x, t) , ур-ние к-рой $dx/dt = C^{(i)}$. Вдоль каждой характеристики волновые поля эволюционируют согласно ур-ниям

$$\sum_{i=1}^n I_i^{(i)}(v_k) \frac{dv_i}{dt} + \sum_{i=1}^n I_i^{(i)}(v_k) b_i(v_k) = 0, \quad (2)$$

где $I_i^{(i)}(v_k)$ — собств. векторы матрицы a_{ij} , соответствующие её собств. значениям $\lambda^{(i)}$.

В том случае, когда для каждого значения μ можно найти ф-цию $r^{(\mu)}$ такую, что $\sum_{i=1}^n I_i^{(i)}(v_k) dv_i \equiv dr^{(\mu)}$, ур-ния (2) упрощаются:

$$\frac{dr^{(\mu)}}{dt} + \sum_{i=1}^n I_i^{(i)}(r^{(\mu)}) b_i(r^{(\mu)}) = 0. \quad (3)$$

В частности, если $b_i = 0$, каждая величина $r^{(\mu)}$ сохраняется вдоль соответствующей характеристики; в этом случае величина $r^{(\mu)}$ наз. инвариантами Римана. Если $n = 2$, а также для линейных систем (1). В случае $n \geq 3$ инварианты Римана существуют только при выполнении специальных ограничений на производные матрицы $a_{ij}(v_k)$. Инварианты впервые были введены Б. Риманом (B. Riemann) в 19 в. при рассмотрении ур-ний газовой динамики. В общем случае, когда $b_i \neq 0$, величина $r^{(\mu)}$ наз. временными Римана.

Следует отметить, что Р. в. существуют, пообщее говоря, в течение ограниченного времени из-за пересечения характеристик, определяемых начальными условиями (см. Самовоздействующие волны).

Лит.: Уилкс Д. Дж., Линейные и нелинейные волны, пер. с англ., М., 1977.

РИМАНА ТЕНЗОР — то же, что кривизнн тензор. РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ — геометрия риманова пространства. Осн. понятия Р. г. являются обобщением понятий евклидовой геометрии на пространства с произвольным метрическим тензором g_{ij} .

Скалярное произведение касательных векторов $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$, $\eta = (\eta^1, \dots, \eta^n)$ в точке x определяется ф-лой $(\xi, \eta) = g_{ij}(x) \xi^i \eta^j$. Это позволяет определить длины векторов ($|\xi| = \sqrt{(\xi, \xi)}$) и углы между векторами a и b данной точки. Длина (s) кривой, $x^i = x^i(t)$, $i = 1, \dots, n$; $a \leq t \leq b$, определяется ф-лой

$$s = \int_a^b |\dot{x}| dt,$$

где $\dot{x} = (x^1, \dots, x^n)$ — вектор скорости.

Расстояние $\rho(x, y)$ между точками x и y определяется как минимум длины кривых, соединяющих точки x и y . Ф-ция $\rho(x, y)$ задаёт метрику в римановом пространстве.

Объём области U риманова пространства определяется ф-лой

$$V(U) = \int_U \sqrt{|\det(g_{ij})|} dx^1 \dots dx^n.$$

На k -мерной поверхности, заданной в римановом пространстве в параметрич. виде, $x^i = x^i(u^1, \dots, u^k)$, $i = 1, \dots, n$, возникает метрич. тензор

$$h_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^i}{\partial u^\alpha} \frac{\partial x^j}{\partial u^\beta} g_{ij}, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, k,$$

наз. первой квадратичной формой поверхности. Длины кривых, углы и объёмы k -мерных областей на поверхности вычисляются в терминах внутренней геометрии, т. е. через первую квадратичную форму. Р. г. двумерных поверхностей в трёхмерном евклидовом пространстве широко применяется в механике оболочек. Большое внимание уделяется изучению минимальных поверхностей, т. е. экстремальной функционала k -мерного объёма. Простейшей их физ. реализацией (при $k = 2$) являются мыльные плёнки. Считается, что двумерные минимальные поверхности в пространстве Минковского описывают классич. динамику струны релятивистской.

Дифференц. исчисление тензоров в римановом пространстве основано на введении симметричной связности, согласованной с метрикой g_{ij} . Её Кристоффеля символы имеют вид

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right).$$

Кривизнн тензор R_{ijkl} этой связности определяет кривизну риманова пространства, характеризующую его отличие от евклидова.

Движения риманова пространства определяют как преобразования, сохраняющие метрику. Однородными группами движений определяются в евклидовой геометрии группы Клиффорда $\xi^i(x)$, удовлетворяющим соотношениям: $\nabla_i \xi_j + \nabla_j \xi_i = 0$, где $\xi_i = g_{ik} \xi^k$, ∇_i — ковариантная производная. Сдвиги

вдоль траекторий системы, $\dot{x}^i = \xi^i(x)$, $i = 1, \dots, n$, определяют движения пространства. Движения n -мерного риманова пространства образуют группу Ли, размерность к-рой не превосходит $n(n-1)/2$. Для общих римановых пространств эта группа тривиальна; примерами пространств с группой движений макс. размерности служат евклидово пространство, сфера (метрика $g_{ij} = 4\delta_{ij}[1 + \Sigma(x^a)^2]$, δ_{ij} — Кронекера символ), пространство Лобачевского (метрика $g_{ij} = 4\delta_{ij}[1 - \Sigma(x^a)^2]$). Если группа движений достаточно богата, так что с помощью движения любую точку x можно перевести в заданную точку y , то риманово пространство наз. однородным. Если для любой точки существует движение, являющееся симметрией пространства с центром в этой точке, то однородное пространство наз. симметрич. и чётским m . Локально симметрические пространства выделяются условием отсутствия кривизны, $\nabla_i R_{ijkl} = 0$. Теория симметрических и римановых однородных пространств сочетает применённо Р. г. и методов теории групп Ли. Идея и методы этой теории используются при изучении однородных космологических моделей общей теории относительности.

Конформными наз. такие преобразования риманова пространства, при к-рых метрика подвергается растяжению, $g_{ij}(x) \rightarrow \lambda(x)g_{ij}(x)$. Конформные преобразования n -мерного риманова пространства при $n \geq 3$ образуют группу Лн, размерность к-рой не превосходит $(n+1)(n+2)/2$. Инвариантностью относительно конформных преобразований обычно обладают теории безмассовых частей.

Геодезическая линия — экстремаль функционала длин, рассматриваемого на кривых с закрепленными концами. Ур-ния геодезических имеют вид

$$\ddot{x}^i + \Gamma_{jk}^i(x)\dot{x}^j\dot{x}^k = 0.$$

Геодезические могут быть получены также как экстремаль функционала действия:

$$S = \int_a^b |\dot{x}|^2 dt = \int_a^b g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j dt.$$

Близкие точки x, y риманова пространства всегда можно соединить локально единственной геодезической, длина к-рой и будет равна расстоянию $\rho(x, y)$. Риманово пространство наз. геодезически полными, если любая геодезическая $x^i(t)$ неограниченно продолжается по t . В полном римановом пространстве любые две точки можно соединить геодезической (вообще говоря, не единственной). Изучение глобальных свойств геодезических риманова пространства составляет важный раздел вариационной исчисления в целом. Поскольку многие ур-ния классич. механики могут быть записаны в виде ур-ний геодезических, методы теории геодезических применимы для получения качеств. информации о характере механич. движения. В общей теории относительности, где массивные частицы движутся по времениподобным (а безмассовые — по изотропным) геодезическим *индифинитной метрики*, в основном изучаются именно такие геодезические. Некоторые глобальные свойства допускают физ. интерпретацию. Так, наличие замкнутых геодезических означает нарушение причинности. Геодезич. неполнота трактуется как наиб. универсальный способ определения сингулярности пространства-времени.

Важная задача Р. г. — установление зависимости между геометрией риманова пространства и его *топологией*. Простейшим примером такой зависимости является ф-ла Гаусса — Боппе, справедливая для замкнутой двумерной поверхности:

$$\frac{1}{4\pi} \oint K d\sigma = 1 - g,$$

где K — гауссова кривизна поверхности, $d\sigma$ — элемент площади, g — топологич. характеристика поверхности, равная числу ручек (напр., для сферы $g = 0$, для тора $g = 1$). Для многомерных римановых пространств строятся более сложные топологич. характеристики (характеристич. классы), вычисляемые в виде интегралов от инвариантов тензора кривизны. Известны также теоремы, выводящие топологич. ограничения на риманово пространство из соотношений типа неравенств для его кривизны. Простейшим примером является такое утверждение: полное односвязное (т. е. любой замкнутой путь стягивается в точку) риманово пространство отрицат. кривизны топологически евклидово.

Комплексный аналог Р. г. — теория пространств с эрмитовой метрикой, записываемой в комплексных координатах x^1, \dots, x^n в виде $ds^2 = g_{ij}dx^i dx^j$ (черта означает комплексное сопряжение), причём $g_{ji} = g_{ij}$. В частности, двумерная метрика может быть записана в комплексном виде $ds^2 = g(x, y)dx dy$, если ввести изотермич. координаты x^1, x^2 , также, что $g_{ij} = g\delta_{ij}$, и положить

$z = x^1 + ix^2, \bar{z} = x^1 - ix^2$ (здесь i — комплексная единица). Конформные преобразования сводятся тогда к комплексно-аналитич. заменам, $z \rightarrow w(z), dw/dz = 0$, и сопряженно $z \rightarrow \bar{z}$.

Большинство методов Р. г. переносится на псевдориманово пространство, в к-рых задана индефинитная метрика, и поэтому являются осп. аппаратом *общей теории относительности*.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Рахевский П. К., Риманова геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 1967; Фок В. А., Теория пространств, времени и гравитации, 2 изд., М., 1981; Дубровин В. А., Новиков С. П., Фомин С. А. Т., Современная геометрия, 2 изд., М., 1986; и ж. е, Современная геометрия. Методы теории гомологии, М., 1984. Б. А. Дубровин.

РИМАНОВА ПОВЕРХНОСТЬ — поверхность, локально устроенная как область комплексной плоскости S (комплексное аналитич. многообразие). Если X — некая поверхность (многообразие), представляемая в виде объединения открытых подмножеств (U_i) , каждое из к-рых эквивалентно век-рой области Ω_i в S , то говорят, что на X задана структура Р. п. Др. словами, существуют ф-ции f_i , непрерывно и взаимно однозначно отображающие Ω_i на U_i , причём для любой пары индексов i и j ф-ции перехода $f_j^{-1} \circ f_i$ являются *аналитическими функциями*, взаимно однозначно отображающими $f_i^{-1}(U_i \cap U_j)$ на $f_j^{-1}(U_i \cap U_j)$. Пара (U_i, f_i) наз. к а р т о й, а совокупность всех карт, покрывающих X , — атласом. Ниже приведены примеры Р. п.

1. Всякая область Ω в S является Р. п. При этом атлас можно выбрать состоящим из одной карты, положив $U = \Omega$ и f , равной тождеств. отображению.

2. Расширенная комплексная плоскость (сфера Римана) S , получающаяся добавлением к S бесконечно удалённой точки, является Р. п. В этом случае атлас можно выбрать состоящим из двух карт, положив, напр.,

$$U_1 = \{z \in S : |z| < 2\}, f_1(z) = z, \\ U_2 = \{z \in \bar{S} : |z| > 1\}, f_2(z) = 1/z.$$

Ф-ция f_1 отображает круг $\{|z| < 2\}$ на себя, а ф-ция f_2 отображает внешность единичного круга на единичный круг. При этом бесконечно удалённая точка переходит в нуль.

3. Р. п. аналитич. ф-ции. Если ф-ция $f(z)$, первоначально заданная в нек-рой окрестности точки z_0 , допускает *аналитическое продолжение* вдоль к.-л. замкнутого контура, причём в результате этого продолжения тождества ф-ция с др. значениями в окрестности z_0 , то точку z_0 до обхода этого контура и ту же точку после его обхода естественно считать разл. точками. Проводя эту процедуру со всеми точками первонач. области определения ф-ции, получаем в результате неограниченную область, имеющую структуру Р. п. и называемую Р. п. ф-ции $f(z)$. При обходе вдоль контура описанного выше типа говорят о переходе Р. п. на другой лист. Р. п. аналитич. ф-ций позволяет рассматривать *многозначные функции* в S как однозначные ф-ции на своих Р. п.

4. Пусть Ω — нек-рая область в S и Γ — нек-рая группа взаимно однозначных аналитич. отображений Ω в себя, причём совокупность точек, получающихся из $z \in \Omega$ при действии Γ , образует дискретное множество в Ω . Отжидаясь точки Ω , переходящие друг в друга при преобразованиях из Γ , можно определить поверхность (многообразие), к-рая имеет структуру Р. п. и обозначается Ω/Γ . Напр., преобразования $z \rightarrow z + z_0$, где z_0 — фиксиров. число, приводят к поверхности, топологически эквивалентной цилиндру.

Согласно теореме об униформизации, любая связная Р. п. эквивалентна либо \bar{C} , либо S/Γ , либо $S/\Gamma, \Gamma$ где $S_\pm = \{z = x + iy : y > 0\}$ — верхняя полуплоскость. Др. словами, существует аналитич.

ф-ция, взаимно однозначно отображающая связную Р. п. на одну из перечисленных.

Р. п. применяются в разл. областях теории ч. и матем. физики. В частности, в квантовой теории поля часто изучаемые величины (амплитуды рассеяния, формфакторы и т. д.) являются многозначными аналитич. ф-циями. При этом переход с одного листа Р. п. на другой обычно интерпретируют как переход от реальных состояний частиц к виртуальным и наоборот. Др. примеры могут служить плоскость Лобачевского и фазовые пространства динамических систем.

Лит. см. при ст. Аналитическая функция. В. И. Завьялов. **РИМАНОВО ПРОСТРАНСТВО** — пространство, точки к-рого однозначно задаются координатами $x = (x^1, \dots, x^n)$ (быть может, локально) и в к-ром определён метрический тензор g_{ij} . Число n наз. размерностью пространства. В случае, когда Р. п. не допускает введения единой системы координат (напр., её нет на сфере), предполагают, что на нём задана структура многообразия. Это означает, что Р. п. разбито на области U_1, U_2, \dots , причём в каждой области U_p заданы свои координаты x^p_1, \dots, x^p_n , требуется, чтобы для пересекающихся пар областей U_p, U_q координаты x^p_1, \dots, x^p_n гладко выражались через координаты x^q_1, \dots, x^q_n и наоборот. В каждой области U_p задётся метрич. тензор $g^p_{ij}(x_p)$, причём на пересечении U_p и U_q компоненты g^p_{ij} и g^q_{kl} связаны тензорным законом преобразования:

$$g^p_{ij}(x_p(x_q)) \frac{\partial x^p_i}{\partial x^q_k} \frac{\partial x^p_j}{\partial x^q_l} = g^q_{kl}(x_q).$$

Простейшим примером Р. п. является *евклидово пространство*, где в примот. координатах метрич. тензор $g_{ij}(x) = \delta_{ij}$ (δ_{ij} — Кронекера символ). Если тензор g_{ij} задаёт *инфинитесим. метрику*, то пространство наз. севдоримановым. Простейшим примером таких пространств является четырёхмерное пространство-время специальной теории относительности (пространство Минковского). Геометрия Р. п. составляет предмет *римановой геометрии*. Севдоримановы пространства изучаются общей *относительности теорией*.

Лит.: Фок В. А., Теория пространств, времени и тяготения, 2 изд., М., 1964; Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоминко А. Т., Современная геометрия, 2 изд., М., 1986.

РИЧЧИ ТЕНЗОР — дважды ковариантный симметрический тензор $R_{ij}(x)$, служащий одной из характеристик кривизны *риманова пространства* (или севдориманова пространства). Введён Г. Риччи (G. Ricci) в 1903–1904. Если g_{ij} — метрический тензор этого пространства, R^{ikl} — соответствующий кривизны тензор, то компоненты Р. т. определяются свёрткой:

$$R_{ij} = R^{kl}{}_{ik} = g^{kl} R_{likj},$$

где g^{kl} — контравариантные компоненты метрич. тензора. Свёртка $R = g^{ij} R_{ij}$ является скаляром (не зависит от выбора координат) и наз. скалярной кривизной. Для двумерных пространств справедливо соотношение $R_{ij} = (1/2)Rg_{ij}$; скалярная кривизна R связана с гауссовой кривизной соотношением $R = 2K$. Для трёхмерного пространства тензор кривизны выражается алгебраически через Р. т. и метрику:

$$R_{ijkl} = R_{iklj} - R_{iljk} + R_{iljk} - R_{jkli} + (R/2)(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}).$$

В общей *относительности теории* через Р. т. записываются ур-ния гравит. поля. В пустом пространстве эти ур-ния принимают вид: $R_{ij} - (1/2)Rg_{ij} = 0$ или $R_{ij} = 0$; четырёхмерные римановы пространства, удовлетворяющие этому соотношению, наз. простран-

ствами Эйнштейна. Скалярная кривизна R является плотностью *лагранжиана* Гильберта — Эйнштейна ур-ний общей теории относительности.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоминко А. Т., Современная геометрия, 2 изд., М., 1986.

РККИ-ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (взаимодействие Рудермана — Киттеля — Касуи — Иосиды) — косвенное обменное взаимодействие между магн. ионами, осуществляемое через коллективизиров. электроны проводимости. РККИ-о. в. возникает в металлах и полупроводниках, где коллективизиров. электроны проводимости выступают посредниками обменного взаимодействия (ОВ) ионов, обладающих локализов. спинами, незаполненных d - и f -оболочек. В частности, РККИ-о. в. наблюдается в редкоземельных металлах и их сплавах. Благодаря сильной локализации электронов $4f$ -оболочек перекрытие волновых ф-ций электронов соседних ионов слишком мало и прямое ОВ в таких веществах не может обеспечить наблюдаемое магн. упорядочение.

Идея косвенного ОВ посредством коллективизиров. носителей магн. момента высказана М. Рудерманом и Ч. Киттелем [1] в работе, посвящённой теории *сверхтонкого взаимодействия*. Т. Касуя [2] и К. Иосида [3] предположили, что механизм возникновения эффективного ОВ между магн. моментами ионов аналогичен механизму возникновения эфф. взаимодействия между ядерными спинами.

Локализов. спии, погружённый в «облако» электронов проводимости, создаёт спиновую поляризацию этого облака, причём поляризация носит осциллирующий (в пространстве) характер. Спины электронов проводимости стремятся экранировать локализов. спии, подобно тому как заряд электронов стремится экранировать положит. заряд погружённого в их облако иона. Аналогично тому, как при экранировании положит. заряда в облаке электронов возникает довольно слабо затухающие с расстоянием осцилляции концентрации электронов, возникают и слабо затухающие осцилляции спиновой поляризации. Эти осцилляции воспринимаются другими локализов. спинами в той области пространства, где они локализованы, и в результате появляются осциллирующий потенциал взаимодействия между спинами.

Интеграл эффективного РККИ-о. в. можно рассчитать в рамках микроскопической $s-f$ -обменной модели. Локализованные на фоне электронов частично заполненные оболочки описываются локализованными (атомными) волновыми ф-циями (f -подсистема), электроны проводимости описываются блоховскими функциями (s -подсистема) и на *благосклонных электронах*. Прямым $f-f$ -ОВ можно пренебречь, т. к. расстояние между соседними ионами превышает радиус f -оболочки. Гамильтониан системы можно записать в виде

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_s + \mathcal{H}_{sf},$$

где \mathcal{H}_s — гамильтониан подсистемы электронов проводимости, а \mathcal{H}_{sf} — гамильтониан $s-f$ -ОВ:

$$\mathcal{H}_{sf} = \sum_{i,n} I(r_j - R_n) (s_j S_n),$$

а здесь $I(r_j - R_n)$ — интеграл ОВ s -электрона со спином s_j , находящегося в точке с радиусом-вектором r_j , с f -электронами n -го иона, обладающего результирующим спином S_n и локализованного в точке с радиусом-вектором R_n . Оценки величины I показывают, что $I \sim 10^{-14} - 10^{-13}$ эрг, в то время как *ферми-энергия* для электронов проводимости $\epsilon_F \sim 10^{-11} - 10^{-12}$ эрг, т. о., параметр I/ϵ_F можно считать малым. Применения *возмущенной теории* по этому малому параметру, можно рассчитать эфф. интеграл ОВ. Поправка к энергии в

первом порядке по теории возмущений не возникает, если предположить, что в основном состоянии электронов проводимости находится в неполяризованном состоянии, т. е. имеется равное число электронов со спинами, направленными вдоль и против намагниченности. Поправка второго порядка имеет вид

$$\delta^2 = \frac{P_n^2}{2N^2} \sum_{k, k'} \sum_{n, m} \frac{\theta(|k-k_F|)\theta(k'-|k-k'|)}{\epsilon(k')-\epsilon(k)} \times \exp(-i(k-k')(R_n-R_m)) / (S_n \cdot S_m) /,$$

где N — число ионов, θ — ступенчатая тета-функция Дирака, $\epsilon(k)$ — дисперсия закон электронов проводимости (ϵ — энергия, k, k' — волновые векторы), k_F — значение волнового вектора на Ферми-поверхности ($\epsilon(k_F) = \epsilon_F$ — Ферми-энергия), $|j\rangle$ — вектор состояния, описывающий основное состояние j -подсистемы. Эта поправка соответствует эфф. гамильтониану гейзенберговского типа (см. Гейзенберга модель):

$$\mathcal{H}_{\text{эфф}} = - \sum_{n, m} I_{n, m}^{\text{РККИ}} (S_n \cdot S_m).$$

Число j -электронов и, следовательно, величина спина S_n одинаковы для всех ионов. Зависимость интеграла $I_{n, m}^{\text{РККИ}}$ от расстояния между магн. ионами $R_{n, m} = |R_n - R_m|$ определяется законом дисперсии электронов проводимости $\epsilon(k)$ и степенью заполненности проводимости зоны. Строгий расчёт $I_{n, m}^{\text{РККИ}}$ осложнён учётом вклада от электронов, лежащих глубоко под поверхностью Ферми, где их нельзя считать квази-свободными при любом законе дисперсии. Эфф. гамильтониан можно определить, предположив квадратичный закон дисперсии электронов проводимости

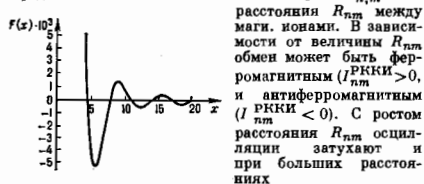
$$\epsilon(k) = \hbar^2 k^2 / 2m^*$$

где m^* — эффективная масса s -электрона. Тогда

$$I_{n, m}^{\text{РККИ}} = \frac{P_k^2}{\epsilon_F} \frac{V^2}{N^2(2\pi)^3} F(2k_F, R_{n, m}),$$

здесь V — объём тела, $F(x) = (\sin x - x \cos x) / x^4$

(график этой ф-ции изображён на рис.). Ф-ция $F(2k_F R_{n, m})$ определяет зависимость обменного интеграла $I_{n, m}^{\text{РККИ}}$ от



$$I_{n, m}^{\text{РККИ}} \sim R_{n, m}^{-3}$$

В отличие от короткодействующего прямого ОВ, РККИ-о. в. имеет большой радиус. Интеграл $I_{n, m}^{\text{РККИ}}$ сильно зависит от концентрации свободных носителей варада n_p . Т. к. $k_F = (3\pi^2 n_p)^{1/3}$, $I_{n, m}^{\text{РККИ}} \sim n_p^{1/3}$. Поэтому в диэлектриках, где концентрации свободных носителей варада очень мала, РККИ-о. в. можно не учитывать.

РККИ-о. в. позволяет объяснить существование ряд. магн. структур. Так, если ближайшие магн. соседи расположены на расстояниях, при к-рых $I_{n, m}^{\text{РККИ}} > 0$, то существуют ферромагн. упорядочение, если $I_{n, m}^{\text{РККИ}} < 0$, —

то антиферромагнитное. Более сложные магн. структуры, напр. геликоидальные, можно также объяснить с помощью существования аналогичного ОВ.

Лит.: 1) R u d e r m a n M. A., K i t t e l C., Indirect exchange coupling of nuclear magnetic moments by conduction electrons, «Phys. Rev.», 1954, v. 96, p. 99; 2) K a s u y a T., A theory of metallic ferro- and antiferromagnetism on Zener's model, «Prog. Theor. Phys.», 1956, v. 16, p. 45; 3) У о и д К. A., Magnetic proper... of Cu-Mn alloys, «Phys. Rev.», 1957, v. 106, p. 583; 4) У а й т Р. M., Квантовая теория магнетизма, пер. с англ., 2 изд., М., 1965. А. В. Вебер, О. А. Котельников.

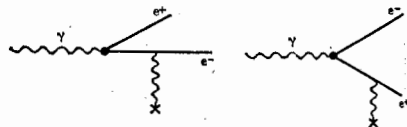
РОДИЙ (Rhodium), Rh, — хим. элемент VIII группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 45, ат. масса 102,9055, входит в платиновую группу *благородных металлов*. В природе представлен стабильным ^{103}Rh . Металлич. радиус 0,134 нм, радиус иона Rh^{2+} 0,075 нм, Rh^{3+} 0,065 нм. Электронная конфигурация внеш. оболочек $4d^8 4s^2 5s^2$. Энергии последоват. ионизации равны соответственно 7,46; 18,08; 31,06 эВ. Значение электроотрицательности 1,45.

В свободном виде серебристо-белый металл с кубич. гранецентрированной кристаллич. структурой, с постоянной $a = 0,379$ нм. Плотн. 12,41 кг/дм³, $t_{\text{пл}} = 1963$ °C, $t_{\text{кип}} = 3627-3700$ °C. Уд. теплота плавления 20 кДж/моль, испарения 494 кДж/моль, уд. теплоёмкость $c_p = 25,0$ Дж/(моль·К). Темп-ра Дебая 362–480 К. Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 0,002 К. Работа выхода электрона 4,75 эВ. Термич. коэф. линейного расширения $(8,45-8,5) \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (при 283–313 К). Уд. электрич. сопротивление 0,0394 мОм·м (при 273 К). Термич. коэф. электрич. сопротивления $4,57 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (при 273–373 К). Теплопроводность 152 Вт/(м·К) (при 300 К). Тв. по Бриллеу 540–1360 МПа, модуль упругости 275–315 ГПа, модуль сдвига 150 ГПа. Обладает высокой отражат. способностью и видовой области спектра.

Химически малоактивен, в соединениях проявляет степень окисления +3. Заметно адсорбирует водород. Р. применяется для покрытия зеркал, в качестве катализатора хим. реакций (в сплавах с др. платиновыми металлами), служит припоём при пайке Mo и W. Сплавы Rh с Pt и Ir — материал для высокотемпературных термомп. Нуклиды $^{103\text{m}}\text{Rh}$ (изомерный распад, β^- -распад, $T_{1/2} = 56,1$ мин) и $^{106\text{m}}\text{Rh}$ (β^- -распад, $T_{1/2} = 130$ мин) могут использоваться в качестве радиоакт. индикаторов. С. С. Беркоуко.

РОЖДЕНИЕ ПАР — часть а — а частица — один из видов взаимопревращения элементарных частей, в к-ром в результате эл.-магн. или к.-л. др. взаимодействия одновременно возникают частица и античастица. Возможности Р. п. (как и аннигиляция пар) предсказывалась как следствие релятивистского Дирака уравнения. В 1933 И. и Ф. Жолио-Кюри (I. и F. Joliot-Curie) с помощью камеры Вильсона, помещённой в магн. поле, наблюдали рождение электрон-позитронных пар γ -квантами от радиоакт. источника.

Согласно законам сохранения энергии-импульса, Р. п. одиночным фотоном невозможно. Процессы Р. п. фотоном в кулоновском поле (на рис. помещено крестиком) ядра и атомных электронов при энергии фотона



ϵ_{γ} , превышающей удвоенную энергию покоя электрона, и при ϵ_{γ} больше 10–30 МэВ (в зависимости от вещества), являются гл. механизмом потери энергии γ -квантов при их прохождении через вещество (см. Гамма-излучение). Возможен также процесс Р. п. виртуальным фотоном γ^* (см. Виртуальные частицы), образова-

цям в процессе столкновения или распада частиц. Такой механизм Р. п. наз. также конверсией фотона. Если энергия фотона (реального или виртуального) очень велика, то он может породить любую пару частица — античастица, напр. мюонов $\mu^+\mu^-$. Если при эл.-магн. переходе в ядре образование реального фотона запрещено законом сохранения полного момента, то такой переход происходит только за счёт процесса конверсии *внутренней* μ -кванта или (при достаточно большой энергии) за счёт конверсии γ -кванта в электрон-позитронную пару (парная конверсия).

В столкновениях частиц высоких энергий наблюдаются также рождение мюонных пар. В адронных столкновениях Р. п. $\mu^+\mu^-$ связывают с эл.-магн. аннигиляцией кварков и антикварков, входящих в состав адронов, или с процессами конверсии фотонов тормозного излучения, образованных при столкновениях кварков с кварками или глюонами. Поэтому процессы Р. п. $\mu^+\mu^-$ и e^+e^- с большими поперечными (по отношению к оси соударения) импульсами анализируют в рамках *квантовой хромодинамики* и кварк-партоновой модели (см. *Партоны*). В Р. п. $\mu^+\mu^-$ с малыми поперечными импульсами важную роль могут играть эл.-магн. распады адронов (напр., $\eta \rightarrow \gamma + \mu^+ + \mu^-$, $\omega \rightarrow \pi^0 + \mu^+ + \mu^-$).

Изучение процессов Р. п. (конверсии) в эл.-магн. распадах адронов позволяет получить информацию об эл.-магн. факторах адронов. Процессы Р. п. новых тяжёлых частиц — *c*- и *b*-кварков или *tau*-лептонов и их последующие лептонные распады являются источником пар т. н. прямых лептонов в адронных столкновениях.

В общем случае любой процесс образования пары частиц с противоположными лептонными или барьонными зарядами можно рассматривать как процесс Р. п. лептонов или кварков, напр. e^+e^- , *и др.*

Лит.: Тянг С., Открытие *j*-частиц, пер. с англ., «УФН», 1978, т. 125, в. 2, с. 227.

R-ОПЕРАЦИЯ в квантовой теории поля — матем. процедура, применяемая к коэффициентным ϕ -функциям (см. *Операторное разложение, Производящий функционал*) матричных элементов матрицы рассеяния с целью устранения из них ультрафиолетовых расходимостей.

В простых случаях процедуру перенормировок удобно и наглядно проводить с помощью контурных. Однако для коэффициентных ϕ -функций высших порядков, отвечающих *Фейнмана диаграммам* сложной топологии, напр. содержащим т. н. перекрывающиеся расходимости, операция вычитания расходимостей требует чёткой и однозначной формулировки. Такая формализация в импульсном представлении была получена в сер. 1950-х гг. Н. Н. Боголюбовым и О. С. Парасюком в виде теоремы о перенормировках (см. *Боголюбов — Парасюк теорема*). Репертурная часть этой теоремы, известная под назв. *R-О. Боголюбова*, устанавливает относительно простое правило получения конечного, т. е. не содержащего УФ-расходимостей, выражения для коэффициентной ϕ -функции T_n , соответствующей произвольной диаграмме G (обобщённому узелу) данного порядка теории возмущений.

Теорема о перенормировках утверждает, что конечная коэффициентная ϕ -функция T_n , отвечающая данной связанной диаграмме n -го порядка G , может быть получена из первонач. выражения T_n применением операции

$$R(G) = 1 + \sum_{2 \leq m \leq n-1} \Delta(G_1) \dots \Delta(G_m) + \Delta(G),$$

причём сумма берётся по всем возможным разбиениям совокупности элементарных вершин x_1, \dots, x_n (и соединяющих их линий) диаграммы G на поддиаграммы (обобщённые узлы) G_i :

$$G = G_1 * G_2 * \dots * G_m$$

($*$ — топологич. произведение). Операция Δ определяется следующим образом: для несвязных и слабосвязных (т. н. *одночастично приводимых*) диаграмм, а также сходящихся диаграмм $\Delta(G) = 0$. Если к-л. из поддиаграмм G_i совпадает с элементарной вершиной x_i , то $\Delta(G_i) = 1$. Для слабосвязных расходящихся диаграмм

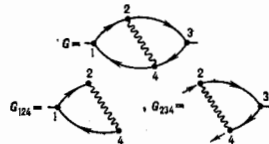
$$\Delta(G) = -M(G) \sum_m \Delta(G_1) \dots \Delta(G_m),$$

где символ M отвечает операции вычитания из исходного выражения $f(k)$ его $\omega(G) + 1$ первых членов разложения в ряд Лорана (или Тейлора) ($f(k)$) $_{\omega}$ по внешней импульсной переменной k :

$$M(G) f(k) = (f(k))_{\omega},$$

причём степень ряда $\omega(G)$ равна степени расходимости импульсного Фейнмановского интеграла, отвечающего диаграмме G .

Для иллюстрации рассмотрим диаграмму 4-го порядка (рис.), описывающую один из двухпетлевых вкладов



в поляризацию вакуума в квантовой электродинамике. Эта диаграмма $G = G_{1234}$ содержит две логарифмически расходящиеся поддиаграммы G_{124} и G_{234} , так что $\omega_{124} = \omega_{234} = 0$. Диаграмма G в целом расходится квадратично $\omega(G) = 2$. Поэтому в данном случае

$$R(G) = [1 - M(G)](1 + \Delta_{124} + \Delta_{234}) = [1 - M(G)](1 - M_{124} - M_{234}).$$

Операторы M_{124} и M_{234} вычитают логарифмич. расходимости поддиаграмм G_{124} и G_{234} . Оператор $M(G)$ вычитает квадратичную расходимость диаграммы G в целом.

Как видно, при формулировке *R-О.* используются в основном топологич. понятия, а устранение расходимостей выполняется путём вычитания из первонач. формального выражения конечных отрезков рядов Тейлора по внешним импульсным переменным. Поэтому *R-О.* можно рассматривать как операцию вычитания расходимостей, к-рую можно реализовать без использования вспомогат. регуляризаций и употребления контурных. Такой взгляд отвечает подходу к УФ-расходимостям, основанному на переопределении произведения пропагаторов, рассматриваемых как обобщённые ϕ -я в окрестности сетовых конусов.

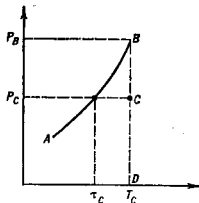
Лит.: Боголюбов Н. Н., Шарнов Д. В., Введение в теорию квантовых полей, 4-й изд., М., 1984, § 29, 30; Завьялов О. И., Перенормированные диаграммы Фейнмана, М., 1979, гл. 2. Д. В. Шарнов.

РОСТ КРИСТАЛЛОВ — см. *Кристаллизация*.

РОСЫ ТОЧКА — темп-ра (t), до к-рой должен охладиться воздух, чтобы находящийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения (при данной влажности воздуха и неизменном давлении; рис.). При достижении Р. т. в воздухе или на предметах, с к-рыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Р. т. может быть вычислена по значениям темп-ры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсационным гигрометром. При отсуств. влажности воздуха 100% ($r = 1$) Р. т. совпадает с темп-рой воздуха (r определя-

ется отношением давления водяного пара к давлению пара, насыщающего воздух при той же темп-ре. При $r < 1$ Р. т. всегда ниже факт. темп-ры воздуха. Так,

Полное давление пара на диаметре влажности давления Р насыщения водяного пара от температуры Т: АВ — кривая насыщения водяного пара; $r = CP/EB = P_c/P_B$ — относительная влажность воздуха; r_c — точка росы для водяного пара, находящегося в состоянии С (при температуре T_c и давлении P_c).



при темп-ре воздуха 15 °С и относит. влажности (%) 100, 80, 60, 40 Р. т. оказываются равной 15,0; 11,6; 7,3; 4,5 °С.

РОТАТОР [от лат. *rotō* — вращаю(сь)] — механич. система, состоящая из материальной точки массы m , удерживаемой с помощью несомесомо жесткого стержня на пост. расстоянии r от неподвижной в пространстве точки O — центра Р., или система таких точек, вращающихся вокруг общей оси с одинаковой частотой. В классич. механике возможное движение для Р. — вращение вокруг точки O . Энергия Р. $E = M^2/2I$, где M — его момент кол-ва движения, I — момент инерции.

В квантовой механике состояния Р. характеризуются определенными дискретными значениями квадрата орбитального момента кол-ва движения $M_l^2 = \hbar^2 l(l+1)$ и его проекции $M_{lz} = m\hbar$ на ось квантования z ($l=0, 1, 2, \dots$ — орбитальное квантовое число, $m = l, l-1, \dots, -l$ — магнитное квантовое число). Возможные значения энергии Р. $E = \hbar^2 l(l+1)/2I$. Р. используется как идеализован. модель при описании вращат. движения молекул и ядер. Так, вращат. уровни энергии молекулы как целого описываются ф-лой для энергии квантового Р.

РОТАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ ЯДЕР — см. *Вращательное движение ядра*.

РОТОН — квазичастица, соответствующая элементарному возбуждению в жидком ^4He в области больших импульсов p , где кривая энергии, спектра возбуждений этой жидкости имеет минимум (см. рис. 3 в ст. *Гелий жидкий*). Вблизи минимума закон дисперсии Р. $E(p)$ имеет вид

$$E(p) \approx \Delta + (p-p_0)^2/2m.$$

Согласно данным по неупругому рассеянию нейтронов, «ротоновая щель» $\Delta/k = 8,7$ К, соответствующий минимум импульсу $p_0 = 1,9 \cdot 10^8$ см $^{-1}$ h, а эфф. масса $m = 0,93 \cdot 10^{-24}$ г.

Р. с достаточной точностью подчиняются *Больцмановской статистике*. Благодаря наличию щели вклад Р. в термодинамич. ф-ции ^4He исключительно падает при понижении темп-ры. Напр., число Р. в единице объема N , ротоновый вклад в теплоемкость c и плотность нормальной компоненты ρ_n равны

$$N = \frac{2(mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^{3/2}} p_0^3 \exp(-\Delta/T); \quad c = n(3/4 + \Delta/T + \Delta^2 T^2),$$

$$\rho_n = (\rho_0/3T)n.$$

При темп-рах $T > 0,8 - 1$ К вклад Р. в термодинамич. ф-ции превышает вклад *фононов*. Два Р. с противоположно направленными импульсами образуют связанное состояние — б-ротоны (орбитальный момент $L = 2$, энергия связи $E_{св}/k \approx 0,25$ К), обнаруженное в экспериментах по комбинационному рассеянию света.

Нагретые тела, помещенные в жидкий ^4He , испускают

Р. и фононы, что позволяет создавать направленные пучки Р. и исследовать рассеяние Р. друг на друг. Лит. см. при ст. *Сверхтекучесть*. Л. П. Пшасекский.

РОТОР (от лат. *rotō* — вращаю) (вихрь) — одна из осн. операций *векторного анализа*, сопоставляющая вектору полю $a(r)$ др. векторное поле $rot a$ (используются также обозначения $\nabla \text{curl } a$). Если точка r задана своими декартовыми координатами, $r = (x_1, x_2, x_3)$, а вектор a — своими компонентами, $a = (a_1, a_2, a_3)$, то $rot a$ имеет компоненты

$$rot a = \left\{ \frac{\partial a_3}{\partial x_2} - \frac{\partial a_2}{\partial x_3}, \frac{\partial a_1}{\partial x_3} - \frac{\partial a_3}{\partial x_1}, \frac{\partial a_2}{\partial x_1} - \frac{\partial a_1}{\partial x_2} \right\}.$$

Согласно *Стокса формуле*, Р. векторного поля определяет его циркуляцию *фадр* вдоль произвольной замкнутой кривой. Если a — распределение скоростей в движущейся жидкости, то значение вектора $rot a$ в каждой точке совпадает с вектором угл. скорости вращения бесконечно малого элемента жидкости, включающего эту точку. Операция Р. обладает след. свойствами:

$$rot(a+b) = rot a + rot b, \quad rot(\varphi a) = \varphi rot a - [a \text{ grad } \varphi],$$

$$rot \text{ grad } \varphi = 0, \quad \text{div } rot a = 0.$$

Если $rot a \equiv 0$, то векторное поле a наз. *безвихревым* или *потенциальным*. В этом случае существует скалярное поле φ (потенциал поля a), такое, что $a = -\text{grad } \varphi$, его можно выразить через объемный интеграл $\varphi = \int dV \text{div } a/4\pi r$, где r — расстояние от элемента объема dV до точки, в n -рой разматкивается значение поля φ . М. Б. Менский.

РОУЛАНДА ОПЫТ — доказал, что *ковалецкинский ток* свободных зарядов на движущемся проводнике по своему магн. действию тождествен с током проводимости в покоящемся проводнике. Этот опыт, поставленный Г. Роуландом (H. Rowland) в 1878, сыграл важную роль в подтверждении ур-ний Максвелла для движущихся сред (см. *Электродинамика движущихся сред*) и справедливости частной (специальной) *относительности теории* (ОТ) применительно к эл.-магн. явлениям.

Согласно частной ОТ, при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой плотности заряда (ρ, ρ') и тока (j, j') преобразуются след. образом:

$$j_{\parallel} = \gamma(j'_{\parallel} + \rho' u); \quad j_{\perp} = j'_{\perp}; \quad \rho = \gamma(\rho' + u j'_{\parallel}/c^2), \quad (1)$$

где $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$, $\beta = u/c$; невзвешенные величины j и ρ относятся к лаб. системе координат, штрихованные (j', ρ') — к системе, движущейся относительно лабораторной с пост. скоростью $u = c\beta$; индексами \parallel и \perp обозначены компоненты векторов, направленные соответственно по и в перпендикулярно ей. При малых u , и $u \ll c$ ($\gamma \approx 1$) соотношения (1) принимают вид

$$j \approx j' + \rho' u \approx j' + \rho u; \quad \rho = \rho' + u j'_{\parallel}/c^2 \approx \rho' + u j'_{\parallel}/c^2. \quad (2)$$

Первое равенство показывает, что если в системе покоя заряда ρ в проводнике имеется ток проводимости, т. е. $j = j_{\text{пров}}$, то при движении такого заряж. проводника в лаб. системе дополнительно к этому току появляется конвект. ток $j_{\text{своб}} = \rho u$ свободных зарядов с плотностью $\rho = \rho_{\text{своб}}$. Этот конвект. ток наблюдался и измерялся в Р. о. Полный ток был равен

$$j_{\text{полн}} = j_{\text{пров}} + j_{\text{своб}}, \quad j_{\text{своб}} = \rho_{\text{своб}} u. \quad (3)$$

Из второго равенства в (2) следует, что перемещение с пост. скоростью u незаряженного ($\rho' = 0$) проводника с током ($j' = j_{\text{пров}}$) приводит к появлению на нем в лаб. системе заряда с плотностью $\rho \approx u j_{\text{пров}}/c^2$. Это ещё одно важное следствие теории относительности.

Схема Р. о. состояла в следующем. Диэлектрик. диск (из зобита или стекла) с поперечными боковыми по-

верхностями вращался вокруг своей оси между заземленными обкладками конденсатора; на боковую поверхность диска наносились заряды, и их действие при вращении диска обнаружилось с помощью чувствит. магн. стрелки. Опыт показал, что отклонение стрелки пропорц. навесному заряду [т. е. величине $\rho_{\text{своб}}$ в (3)] и угл. скорости вращения (величине ω); при изменении знака заряда или направления вращения диска на обратное отклонение магн. стрелки также меняется на противоположное.

Лит.: Там м. И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Абрагам М. Веккер Р., Теория электричества, пер. с нем., т. 2 — Веккер Р., Электростатическая теория, Л.—М., 1941; Франкфурт У. И., Специальная и общая теория относительности, М., 1988; Меерович Ф. А., Мейерович В. Э., Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электронике, М., 1987. С. Н. Столаров.

РОША ПЛОТНОСТЬ — см. Плотность Роша.

РОША ПРЕДЕЛ — расстояние от планеты (звезды) до её спутника, ближе к-рого спутник разрушается приливными силами. При движении спутника по орбите вокруг планеты (звезды) сила её притяжения, действующая на элемент спутника, компенсируется центробежной силой только в его центре масс. Во всех др. точках спутника такого равенства нет, что и обуславливает приливную силу.

Р. п. назван по имени Э. Роша, поставившего и разрешившего (1847) [1] проблему равновесия жидкого, бесконечно малого (по размерам и массе), несжимаемого, однородного, самогравитирующего спутника, равномерно вращающегося в экваториальной плоскости планеты конечной массы (период осевого вращения спутника предполагался равным орбитальному периоду). Рош показал, что под действием приливных сил спутник приобретает аллисоидальную форму и существует такое расстояние D от центра планеты, ближе к-рого спутник уже не может находиться в равновесии (разрушается приливными силами). Это расстояние (T и n — классич. Р. п.) зависит от радиуса планеты (R) и плотностей планеты и спутника (ρ и ρ'):

$$D = 2,45539(\rho/\rho')^{1/3} R.$$

Приняв результаты своих исследований к системе Сатурна, Рош пришёл к заключению, что кольца Сатурна должны состоять из мелких частиц, т. е. радиус наружного края веш. кольца $\approx 2,2R$, т. е. меньше D (в предположении $\rho = \rho'$). В данном случае Рош пришёл к верному заключению, исходя из неверных предполож., т. к. Р. п. для твёрдого спутника может существенно отличаться от классич. Р. п.

Р. п. для твёрдых тел зависит от их размеров и прочности. При изучении Р. п. для таких тел выделяются два типа разрушения: пластическое (следствие среза) и хрупкое (следствие отрыва). Для хрупких тел наступление разрушения удовлетворительно описывается критерием наибольших нормальных напряжений, для пластичных — критерием наибольших касательных напряжений (см. Прочность предела). Применяя критерий наибольших касательных напряжений и полагая прочность тел $T = 10^8$ дин/см² (что соответствует прочности гранита), Х. Джеффрис [2] определил макс. размер тел (≈ 220 км), не разрушающихся при пролёте вблизи Земли. Однако этот размер может быть и меньше, если тело близко по структуре к хондритам (см. Метеориты) с $T \sim 10^8 - 10^7$ дин/см². Более поздние исследования [3] показали, в частности, что макс. радиус тел с $\rho' \leq (40/19)\rho$, не разрушающихся при движении по орбите вблизи поверхности планеты,

$$r_m = (57/8)T/G\rho\rho',$$

а Р. п. для тел с радиусами более 30 км и $T = 10^8$ дин/см² составляет (1,35—1,38)R (при орбитальном движении) и (1,16—1,19)R (при свободном падении на поверхность планеты). Из-за наличия трещин и неоднородностей реальное тело разрушается сложным образом, и по мере

приближения к планете возможно неоднократное образование осколков.

Теория приливного разрушения тел позволяет, в частности, объяснить наличие близко расположенных (двойных) кратеров на современных поверхностях Земли, Луны и Марса. Земля и др. планеты образовались в результате объединения большого числа твёрдых допланетных тел (см. Происхождение Солнечной системы). Прежде чем упасть на растущую планету, допланетное тело испытывает неск. близких сближений с ней. Достаточно крупное тело может быть разрушено приливными силами, при этом его осколки падают в разные, но близко расположенные точки поверхности планеты, образуя двойные кратеры.

Приливные эффекты играют также роль также в двойных звёздных системах, в к-рых расстояния между звёздами сравнимы с их размерами (см. Темные двойные звёзды, Плотность Роша).

Лит.: Там м. И. Е., Mémoire sur la figure d'une masse fluide, soumise à l'attraction d'un point éloigné, в кн.: Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la Section des Sciences, v. 1—2, (P.), 1847—50; 2) Jefferys H., The relation of cohesion to Roche's limit, «Monthly Notices Roy. Astron. Soc.», 1947, v. 107, № 3, p. 260; 3) Aggarwal H. R., Oberg, C. K., Y. B., Roche limit of a solid body, «Astrophys. J.», 1974, v. 191, p. 677; 4) Роша Э., В. В. Столаров.

РТУТЬ (Hydragyrum), Hg — хим. элемент побочной подгруппы IV группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 80, ат. масса 200,59. Природная Рт — смесь 7 стабильных изотопов: ¹⁸⁰Hg, ¹⁸¹Hg, ¹⁸²Hg, ¹⁸⁴Hg, в к-рой преобладают ²⁰⁰Hg (29,80%) и ²⁰¹Hg (23,13%), а наименьшее содержание имеет ¹⁸⁰Hg (0,14%). Электронная конфигурация веш. оболочек 5s²5p⁴4d¹⁰. Энергия последоват. ионизации 10,438; 18,750; 34,2 эВ соответственно. Атомный радиус 0,160 нм, радиус иона Hg²⁺ 0,112 нм. Значение электроотрицательности 1,23.

В свободном виде в нормальных условиях Рт — серебристая тяжёлая легко испаряющаяся жидкость. Плотность жидкой Рт 13,546 кг/дм³ (при 20°С), твёрдой — 14,193 кг/дм³ (—38,9°С). Твёрдая Рт имеет ромбоэдрич. решётку, её постоянные $a = 0,3463$ и $c = 0,674$ нм, $\chi_{\text{пл}} = -38,86$ °С, $\gamma_{\text{пл}} = 356,86$ °С, уд. теплоёмкость $c_p = 27,99$ Дж/(моль·К), теплота плавления 2,295 кДж/моль, теплота испарения 59,20 кДж/моль. Динамич. вязкость 1,685 мПа·с (при 0°С). Уд. электр. сопротивление 0,947 мОм·см, термич. коэф. электр. сопротивления 0,89·10⁻³ К⁻¹. Темп-ра Дебая 357 К, темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 4,12 К. Поверхностное натяжение 471 мН/м (при 20°С), термич. коэф. линейного расширения 41·10⁻⁶ К⁻¹ (при 195—234 К).

В хим. соединениях проявляет степени окисления +1 и +2. Химически малоактивен, при контакте с кислородом воздуха не окисляется. Пары ртути, а также соединения ртути (сулема HgCl₂ и др.) сильно ядовиты. Работать с Рт следует в хорошо вентилируемых помещениях, используя поддоны. Пролитую ртуть собирают сначала пипеткой с группой, затем ватными тампонами. Окочатив уборку — демеркуризацию — можно проводить, используя, напр., 20%-ный водный раствор хлорида железа. Хранить Рт следует в стальных баллонах, снабжённых плотно закрывающимися пробками. Слой воды на поверхности Рт не предотвращает попадания паров Рт в атмосферу.

Рт применяют для изготовления разл. приборов (термометров, манометров, нормальных элементов, пьезографов и т. д.). Пары Рт используют в люминесцентных лампах. Рт служит рабочим телом в вакуумных насосах, в электрич. переключателях, выпрямителях. Жидкие ртутные катоды применяют при пром. выщелоч. и хлора. Широко используются сплавы Рт с металлами — амальгамы. Радиоакт. нуклид ²⁰³Hg (β^- -распад, $T_{1/2} = 46,7$ сут) находят применение в качестве радиоакт. индикатора.

Лит.: Пугачев И. П., Работа со ртутью в лабораторных и производственных условиях, М., 1972. С. С. Вербонос.

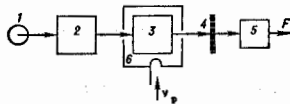
РУБИДИЕВЫЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ — разновидность квантовых стандарт частоты с оптич. накачкой, относится к классу вторичных стандартов. Существуют пассивный Р. с. ч. и активный Р. с. ч. на рубидиевом квантовом генераторе. В службе времени и технике преим. находят применение пассивные Р. с. ч. Относит. нестабильность частоты находится на уровне 10^{-13} за время порядка суток и 10^{-12} за время порядка неск. месяцев. Малогабаритные пассивные Р. с. ч. имеют объём 10^3 см³.

Активный средой в Р. с. ч. являются пары атомов ⁸⁷Rb. Используется переход $S_{1/2}, F_1 = 1, m_F = 0 \rightarrow S_{1/2}, F_2 = 2, m_F = 0$ между подуровнями основного состояния атомов, невозмущенная частота к-рого равна $\nu_0 = 6834682614$ Гц. Зависимость частоты рабочего перехода от магн. поля квадратична и определяется выражением $\nu_p = \nu_0 + 0,08937 H^2$ (Гц $A^{-2} \cdot m^2$). Из-за относительно низкой частоты рабочего перехода равновесная разность населенностей его подуровней невелика и не может уверенно наблюдаться обычными методами радиоспектроскопии.

В квантовом частотном дискриминаторе пассивного Р. с. ч. для увеличения отношения сигнала к шуму при индикации рабочего перехода используются оптич. накачка и индикация. Оптич. излучение соответствующего спектрального состава (содержащее D_1F_1 - и D_2F_2 -компоненты D_1 - и D_2 -линий в спектре излучения атомов ⁸⁷Rb) действует на атомы ⁸⁷Rb, переводя их с подуровней $S_{1/2}, F_1$ основного состояния в возбужденные состояния $P_{1/2}, P_{3/2}$, нарушая тем самым равновесное распределение атомов и существенно повышая разность населенностей подуровней рабочего перехода (населенности подуровней $S_{1/2}, F_2$ растут, а подуровней $S_{1/2}, F_1$ уменьшается). Индикацию рабочего перехода ведут в этом случае по интенсивности света накачки, прошедшего через пары атомов рубидия. Действительно кол-во света, поглощенного в процессе накачки, зависит от числа атомов на подуровне $S_{1/2}, F_1 = 1, m_F = 0$ рабочего перехода. Если в дополнение к свету накачки поддействовать одновременно на атомы рубидия резонансным СВЧ-излучением на частоте рабочего перехода, то оно будет стремиться выровнять населенности, т. е. увеличит разность населенностей подуровней $S_{1/2}, F_1, m_F = 0$. В свою очередь это приведет к увеличению поглощения света накачки и уменьшению его интенсивности на выходе. Эта интенсивность оказывается зависящей от точности настройки частоты СВЧ-излучения на частоту рабочего перехода и, следовательно, может быть использована для его индикации.

В качестве источника света накачки в Р. с. ч. используют газоразрядную спектральную лампу с парами ⁸⁷Rb. В спектре излучения такой лампы присутствуют как нужные для накачки D_1F_1 - и D_2F_2 -компоненты, так и препятствующие накачке D_1F_2 - и D_2F_1 -компоненты. Для устранения нежелательных компонентов свет спектральной лампы пропускают через фильтр, представляющий собой колбу с парами атомов.

Структурная схема квантового дискриминатора Р. с. ч. приведена на рис. Свет накачки от газоразрядной лампы 1 с парами атомов ⁸⁷Rb последовательно проходит через фильтр 2 с парами атомов ⁸⁵Rb, рабочую



ячейку 3 с парами атомов ⁸⁷Rb и поступает на фотоприемник 4 с предриград. усилителем Б на частоте виномод. фазовой модуляции F. Для уменьшения доплеровской ширины линии рабочего перехода рабочая ячейка содержит также смесь инертных газов при дав-

лении неск. торр. Уменьшение уровня радиомощности на частоте ν достигается путем размещения рабочей ячейки в резонаторе 6.

Лит.: Григорьянц В. В., Жаботинский М. В., Золоти В. Ф., Квантовые стандарты частоты, М., 1968. Е. Н. Белозор.

РУБИДИЙ (Rubidium), Rb, — хим. элемент 1 группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 37, ат. масса 85,4678, щелочной металл. Природный Р. — смесь двух изотопов: стабильного ⁸⁵Rb (72,165%) и слабо β -радиоактивного ⁸⁷Rb (27,835%, $T_{1/2} = 4,88 \cdot 10^{10}$ лет). Электронная конфигурация внеш. оболоч. 5s². Энергия последоват. ионизации 4,177; 27,5; 40,0; 52,6; 71,0 эВ соответственно. Атомный радиус 0,248 нм, радиус иона Rb⁺ 0,149 нм. Значение электроотрицательности 0,89.

В свободном виде мягкий серебристо-белый металл, с кубич. объемноцентриров. решеткой с параметром $a = 0,570$ нм. Плотность 1,5248 кг/дм³, $t_{пл} = 39,5^\circ C$, $t_{кип} = 685^\circ C$. Уд. теплоты плавления $c_p = 31,09$ Дж/моль $\cdot K$, теплота плавления 2,192 кДж/моль, теплота сублимации 88,59 кДж/моль. Уд. электр. сопротивление 0,1425 мкОм $\cdot m$ (при $0^\circ C$), термич. коэф. электр. сопротивления 4,7 $\cdot 10^{-3} K^{-1}$ (при $0-25^\circ C$). Парамгнет. магн. восприимчивость $\chi = 0,198 \cdot 10^{-4}$. Темп-ра Дебая 55К. Теплопроводность 35,6 Вт/(м $\cdot K$) (при $20^\circ C$). Термич. коэф. линейного расширения 9 $\cdot 10^{-6} K^{-1}$ (при $0-30^\circ C$).

Химически высокоактивен, на воздухе металлич. Р. воспламеняется. Степень окисления +1. Хим. свойства Р. аналогичны свойствам калия, но Р. ещё более реакционноспособен.

Р. используют как материал для катодов в фотоэлементах, ртутных лампах, в гидридных топливных элементах. Пары Р. применяются в качестве активной среды в лазерах, в чувствит. магнитометрах. RbOH используется в щелочных низкотемпературных аккумуляторах. Соединения Р. вводят в состав спец. стёкол. В качестве радиоакт. индикатора обычно применяют ⁸⁶Rb (β -распад и электронный захват, $T_{1/2} = 18,8$ сут).

Д. С. Ефремов.

РУБИЙ — кристалл Al_2O_3 (корунд) с небольшой добавкой ионов Cr^{3+} , замещающих в кристаллич. решетке корунда ионы Al и окрашивающих корунд в красный цвет (от розового до малиново-красного в зависимости от концентрации Cr). Темп-ра плавления 2050 $^\circ C$. По механич. свойствам Р. близок к корунду (одному из самых твердых минералов). Первоначальное применение в технике получило как материал для часовых подшипников; производство искусств. Р. вначале было налажено для нужд часовой промышленности. В квантовой электронике Р. с 1958 используют в качестве активного вещества в *квантовых усилителях* и твердотельных лазерах. Применение Р. в квантовой электронике связано с особенностями спектра Cr^{3+} и с механич. прочностью.

Уровень энергии иона Cr^{3+} в кристаллич. решетке корунда отличаются от уровней свободного иона Cr^{3+} . *Внутрикристаллич. дефекты* кристаллич. решетки (в т. ч. механич. напряжения и тепловые колебания ионов) размывают уровни энергии Cr (рис. 1). Нек-рые уровни, напр. δ_2 и δ_4 , превращаются в полосы. На положение др. уровней (напр., δ_1) электр. поле влияет слабее, и их уширение незначительно. Переходы с основного уровня δ_1 на широкие полосы δ_2 и δ_4 со-

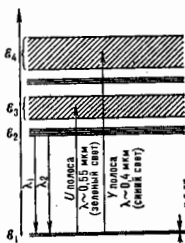


Рис. 1. Схема энергетических уровней иона Cr^{3+} в рубидии.

ответствуют поглощению зелёного и фиолетового света. Переходы с ϵ_1 на узкие уровни ϵ_2 не оказывают влияния на окраску кристалла, т. к. красный свет практически не поглощается. Т. о., положение и ширина полос поглощения ϵ_2 и ϵ_4 определяют красный цвет Р.

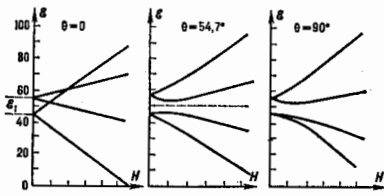


Рис. 2. Расщепление уровней иона Cr^{3+} в рубине в магнитном поле, направление которого параллельно кристаллографической оси кристалла ($\theta = 0^\circ$) и составляет с ней углы $\theta = 0^\circ; 54,7^\circ$ и 90° .

При обычных темп-рах практически все ионы Cr^{3+} находятся на двух нижних уровнях ϵ_1 , отличаясь величиной проекции магн. момента на направление поля $E_{кр}$. Частота перехода между ними $\nu = 11,9 \text{ ГГц}$. Каждый уровень иона Cr^{3+} в Р. дважды вырожден (противоположные знаки проекции магн. момента иона на $E_{кр}$). Магн. поле H дополнительно расщепляет каждый из уровней ϵ_1 на 2, величина расщепления зависит от величины поля H и его ориентации относительно кристаллографич. оси кристалла (рис. 2; см. *Земляна эффект*). Т. о., в Р., находясь в пост. поле H, образуются 4 уровня, переходы между к-рыми находятся в диапазоне СВЧ. Благодаря этому Р. может быть использован как трёхуровневая система в квантовых парамагн. усилителях. Применение Р. в квантовых усилителях обусловлено также большим временем его спин-решеточной релаксации при низких темп-рах и, следовательно, малой потребляемой мощностью накачки.

В лазере оптич. диапазона Р. накачивается светом от мощной лампы с широким спектром излучения, соответствующим переходам с уровней ϵ_1 , на подосы ϵ_2 , ϵ_4 . Подавляющее большинство возбуждённых ионов

мостей уровней ϵ_1 и ϵ_2 и, следовательно, к генерации света с длиной волны λ_1 и λ_2 (рис. 1), что соответствует красному свету (см. *Теоретический лазер*).

Искусств. монокристаллы Р. выращиваются обычно по методу Вернейля в кислородно-водородном пламени (рис. 3; см. также *Монокристаллы вращениями*). Удаётся получить монокристаллы Р. в виде стержней диаметром до 5 см и метровой длины.

Лит. см. при ст. *Теоретический лазер*, *Накачки усилитель*.

РУПОРНАЯ АНТЕННА — антенна в виде отрезка волновода, расширяющегося к открытому концу. Это расширение улучшает согласование Р. а. с открытым пространством и увеличивает её эфф. площадь и угл. разрешение, поскольку увеличиваются размеры излучающего раскрытия, а фазовая скорость волны у раскрытия приближается к скорости света.

Параметры Р. а. определяются размером раскрытия, формой, длиной и конструкцией рупора. В зависимости от назначения используют секторальные, пирамидальные, конические, биконические рупоры и их сочетания с отражающими поверхностями и лизами (напр., в рупоро-параболич. антенне).

Р. а. применяют в СВЧ-диапазоне как самостоят. антенны, облучатели зеркальных антенн, элементы антенных решеток, а также в качестве антенн-зондов в измерит. установках.

Н. М. Дейкина.

РУТЕНИЙ (Ruthenium), Ru, — хим. элемент VIII группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 44, ат. масса 101,07, относится к платиновой группе *благородных металлов*. Природный Ru состоит из 7 изотопов: ^{94}Ru , ^{96}Ru , ^{98}Ru , ^{100}Ru , наиб. распространён ^{100}Ru (31,6%), наименее — ^{98}Ru (1,88%). Металл. радиус 0,133 нм, радиус иона Ru^{4+} 0,062 нм. Электронная конфигурация внеш. оболочек $4s^2 4p^6 4d^7 5s^1$. Энергия последоват. ионизации соответственно равны 7,366; 16,76 и 28,47 эВ. Средство к электрону 1,4 эВ. Значение электроотрицательности 1,42.

В свободном виде хрупкий блестящий серебристый металл, кристаллич. структура имеет гексагональную плотнейшую упаковку с параметрами $a = 0,27057$ нм и $c = 0,42815$ нм. Плотность 12,37 кг/дм³ (по др. данным, 12,06 кг/дм³), $t_{пл} = 2250^\circ\text{C}$, $t_{кип}$ ок. 4100—4200°C. Уд. теплота плавления 24 кДж/моль, теплота испарения 602 кДж/моль. Уд. теплоёмкость $c_p = 24,1$ Дж/моль·К. Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 0,47 К (при напряжённости магн. поля 0,578 А/м). Работа выхода электронов 4,6 эВ. Термич. коэф. линейного расширения $9,91 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (при 323 К). Уд. электр. сопротивление 0,07427 мкОм·м (при 298 К), теплопроводность 116,3 Вт/(м·К). Магн. восприимчивость $0,427 \cdot 10^{-6}$ (при 293 К). Для отожжённого Р. твёрдость по Бриллюе 1790—2160 МПа. Модуль упругости 422—462,8 ГПа (по разл. данным), модуль сдвига 160—170 ГПа.

Р. химически малоактивен, в соединениях проявляет степени окисления от +2 до +8 (наиб. характерны +3, +4, +6 и +8). Р. (особенно полученный электроосаждением) способен адсорбировать значит. кол-во водорода.

Чистый Р. и его сплавы с др. платиновыми металлами применяют в качестве катализаторов хим. реакций, используют для защитного покрытия электрич. контактов. Сплавы Ru, Pt, Rh служат для изготовления фильер. Сплав Ru и Ir применяется при изготовлении высокотемпературных термопар. Нек-рые соединения Р. используют при варке стёкол. В качестве радиоакт. индикаторов применяют β^- -радиоактивные ^{100}Ru ($T_{1/2} = 39,4$ сут) и ^{106}Ru ($T_{1/2} = 367$ сут), образующиеся в ядерных реакторах.

С. С. Бердников.

РЫТОВА МЕТОД — см. *Лазеры возбужденной метод*.
РЭЛЕВСКОЕ РАССЕЯНИЕ — когерентное рассеяние света на оптич. неоднородностях, размеры к-рых значительно меньше длины волны λ возбуждающего света. В отличие от флуоресценции, происходящей с



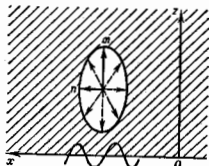
Рис. 3. Выращивание рубина по методу Вернейля. Смесь Al_2O_3 и Cr_2O_3 в виде гудры спускается сверху на вертикальный кристалл, верхняя крошка которого находится в пламени горелки с температурой 2650°C , достаточной для плавления рубина. Кристалл постепенно опускают, и расплавленный слой смеси, выходя из пламени, кристаллизуется.

отдаёт часть своей энергии тепловым колебаниям кристалла и переходит на уровни ϵ_2 , к-рые не заселены при комнатной темп-ре. Время жизни ионов на уровнях ϵ_2 достаточно велико (3,5 мс), и большинство ионов сваливается на них. При достаточно мощной накачке увеличивается населённость уровней ϵ_1 и обогащение населённостей уровней ϵ_2 приводит к *инверсии населён-*

частотами совб. колебаний электронов, возбужденных световой волной, Р. в. происходит с частотами колебаний возбуждающего света. Интенсивность рассеиваемого средой света пропорциональна λ^{-4} . Эта зависимость установлена Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh) в 1871. Подробнее см. в ст. *Рассеяние света*.

РЭЛЕЯ ВОЛНЫ — упругие волны, распространяющиеся в твердом теле вдоль его свободной границы и затухающие с глубиной; разновидность *поверхностных акустических волн*. Их существование было предсказано Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh) в 1885. Примеры Р. в. — волны на земной поверхности, возникающие при землетрясениях, ультразвуковые и гиперзвуковые поверхностные волны в твердых телах, широко применяемые в современных физ. исследованиях и технике.

В плоской Р. в. в одном изотропном упругом полупространстве имеются две компоненты смещения (рис.),



Схематическое изображение волны Рэлея, распространяющейся в направлении оси вдоль свободной границы твердого тела, перпендикулярной оси z, и — компоненты колебательного смещения частиц среды; а также — траектории их движения.

одна из к-рых и направлена вдоль направления распространения волны (ось z), а другая w — перпендикулярно свободной границе вглубь пространства (направление оси z с началом на границе), причём

$$u = Ak \left(z - \frac{2qz}{k^2 + p^2} e^{-sz} \right) \sin(kx - \omega t),$$

$$w = Aq \left(e^{-qz} - \frac{2k^2}{k^2 + p^2} e^{-sz} \right) \cos(kx - \omega t),$$

где t — время, ω — круговая частота, $q = \sqrt{k^2 - k_1^2}$, $s = \sqrt{k^2 - k_2^2}$, k — волновое число Р. в., k_1 , k_2 — волновые числа продольных и поперечных волн соответственно, A — произвольная постоянная.

Толщина слоя локализации Р. в. составляет от λ до 2λ , где λ — длина волны. На глубине λ плотность энергии в волне $\approx 0,05$ плотности у поверхности. Движение частиц в Р. в. происходит по эллипсам, большая полуось к-рых перпендикулярна поверхности, а малая — параллельна направлению распространения волны. Эксцентриситет эллипсов зависит от расстояния до поверхности и от коэф. Пуассона ν упругой среды.

Фазовая скорость Р. в. c_p меньше фазовых скоростей c_1 и c_2 продольных и поперечных волн и определяется из ур-ния

$$\eta^6 - 8\eta^4 + 8(3 - 2\nu)\eta^2 - 16(1 - \nu^2) = 0,$$

где $\eta = c/c_1$, $\xi = c/c_2$. Р. в. соответствует веществу корень этого ур-ния, значения к-рого для твердых сред заключены между 0,874 и 0,955. Приближенное выражение для него $\eta = (0,87 + 1,12\nu)/(1 + \nu)$. Р. в. распространяются без дисперсии, их фазовая скорость равна групповой.

В изотропных средах структура и свойства Р. в. зависят от типа изотропии и направления распространения волны. Р. в. могут распространяться не только по плоской, но и по криволинейной свободной поверхности твердого тела. При этом меняются их скорость, распределение смещений и напряжений с глубиной, а также спектр допустимых частот, к-рый на непрерывного может стать дискретным, как, напр., для случая Р. в. на поверхность сферы.

Иногда под Р. в. понимают волны не только на свободной границе твердого тела, но также поверхностные волны более общего типа, возникающие на границе твердого тела с жидкостью и на границе системы твердых или жидких слоев с полупространством.

Р. в. широко используются во всех областях науки и техники. Напр., низкочастотные (10^2 — 10^4 Гц) Р. в. применяют в сейсмологии для регистрации землетрясений и в сейсморазведке. В УЗ-диапазоне частот Р. в. используются для всестороннего контроля поверхностного слоя образца: исследования характеристик поверхностного слоя, выявления поверхностных и околоповерхностных дефектов (см. *Дефектоскопия*), определения остаточных напряжений поверхностного слоя металла, термич. и механич. свойств поверхностного слоя образца. Гиперзвуковые (10^8 — 10^{10} Гц) Р. в. широко используются в акустоэлектронике при создании преобразователей эл.эктр. сигналов, ультразвуковых линий задержки, усилителей эл.-магн. колебаний и систем для обработки информации.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория упругости, 4 изд., М., 1987, гл. 3, § 24; Бреховский Л. М. Волны в сплошных средах, 2 изд., М., 1973, гл. 1, § 6; Физическая акустика, под ред. У. Манни и Р. Тейсона, пер. с англ., т. 7, М., 1974, гл. 4; Вильямс и Горов И. А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах, М., 1981. И. А. Викторова

РЭЛЕЯ ДИСК — прибор для абсолютного измерения колебательной скорости частиц в акустич. волнах, распространяющихся в газах и жидкостях. Р. д. представляет собой тонкую круглую пластинку из легкого металла или слюды, подвешенную на длинной тонкой (обычно кварцевой или металлической) нити и снабженную зеркальцем для измерения его поворота вокруг вертикального осн. Поворот Р. д. вызывается вращающим моментом M , обусловленным действием средних по времени гидродинамич. сил при обтекании его потоком (см. *Бернулли уравнение*). Поскольку величина квадратично зависит от скорости потока, Р. д. чувствителен как к пост. потокам, так и к знакопеременному полю скорости в акустич. волне. Действие момента M уравновешивается упругостью нити по отношению к закручиванию.

Величина колебат. скорости v определяется по ф-ле: $v = U \sqrt{3\theta/4\rho r^2 \sin^2 2\theta}$, где θ — малый угол, на к-рый поворачивается диск и к-рый наблюдают по отклонению отраженного от зеркальца светового луча, ρ — плотность среды, θ_0 — угол между нормалью к диску до включения звука и направлением колебат. скорости, коэф. упругости кручения нити $t = 4\pi^2 M / T^2$ определяется по периоду T свободных колебаний и моменту инерции M Р. д., r — радиус диска, к-рый должен быть много меньше длины волны звука λ . Р. д. обычно устанавливаются под углом $\theta_0 = 45^\circ$ к г. к. при этом его чувствительность максимальна. Чувствительные Р. д. позволяют определять малые колебат. скорости $v \sim 0,1$ см/с. В *звуковых полях*, где имеют место простые соотношения между колебат. скоростью, звуковым давлением p и интенсивностью звука I (напр., в поле плоской волны), Р. д. используются для определения p и I .

К недостаткам Р. д. как приемника звука относятся его инерционность. Р. д. подвержен влиянию пост. потоков, как конвекционных, так и возникающих в звуковом поле, что снижает точность измерений. Применение Р. д. ограничено областью звуковых и иррадиат. УЗ-частот из-за необходимости соблюдения условия $g \ll \lambda$. При измерениях в воде нужно учитывать поправку на присоединенную массу и на увеличение Р. д. потоком.

Лит.: Беранек Л. Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952, гл. 4, а также И. А. Ультразвуковая техника, пер. с нем., М., 1962. И. П. Гольдман

РЭЛЕЯ ЗАКОН МАГМАТИЗИРОВАНИЯ — установленная эмпирически Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh, 1887) зависимость намагниченности M (или магн. индукции H) ферромагнетика от напряженности индукт. поля H в области $H \ll H_c$ (где H_c — *коэффициент*

ная сила материала). Для кривой начального намагничивания Р. з. н. имеет вид

$$M = \chi_{обр} H \pm RH^2,$$

где $\chi_{обр}$ — обратная магнитная восприимчивость, R — постоянная Раля, знак «+» соответствует $H > 0$, знак «-» $H < 0$.

Установившаяся петля гистерезиса магнитного, согласно Р. з. н., описывается ур-нием

$$M = \chi_{обр} H + RH_m H \pm (R/2) (H^2 - H_m^2),$$

где знак «+» перед вторым слагаемым соответствует восходящей ветви гистерезиса, а знак «-» — нисходящей. H_m — макс. значение магн. поля. Эти закономерности выполняются не только вблизи размагниченого состояния, но и любого др. состояния на плоскости (M, H) при условии, что $H, H_m \ll H_c$. При этом параметры $\chi_{обр}$ и R для разных состояний имеют разные значения. Коэф. $\chi_{обр}$ характеризует линейную, обратную часть процесса намагничивания, связанную с обратимыми смещениями доменных стенок. Для размагниченого состояния $\chi_{обр}$ совпадает с обратной начальной восприимчивостью χ_0 . Постоянная R определяет вклад в намагниченность необратимых смещений доменных стенок. Необходимое условие для выполнения Р. з. н. — медленное, квазистатич. изменение магн. поля, сводящее к минимуму эффекты, связанные с магн. последствием (магнитной вязкостью). Р. з. н., как показал Е. И. Кундорский (1938), может быть выведен теоретически из рассмотрения процессов намагничивания с учётом статистич. распределения критич. поля смещения доменных стенок.

Лит.: Подьянов К. М., Ферромагнетизм, М.—Л., 1957; Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971.

РЭЛЁН ИНТЕРФЕРОМЕТР — см. Интерферометр Рэля.

РЭЛЁН КРИТЕРИЙ — условие, введенное Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh), согласно к-рому изображения двух близлежащих точек можно видеть раздельно, если расстояние между центрами дифракц. пятен каждого из изображений не меньше радиуса первого тёмного дифракц. кольца. Подробнее см. в ст. Разрешающая способность.

РЭЛЁН ЧИСЛО — подобия критерий, характеризующий отношение потока тепла в жидкости или газе за счёт подъёмной (архимедовой) силы, возникающей вследствие неравномерности поля темп-ры у поверхности тела, к теплопроводности среды; Р. ч.

$$Ra = g \beta \Delta T l / \nu,$$

где g — ускорение свободного падения, l — характерный размер, β — температурный коэф. объёмного расширения среды, ΔT — разность темп-р поверхности тела и среды, ν — коэф. кинематич. вязкости, α — коэф. температуропроводности среды. Р. ч. представляет собой, по существу, произведение Грасгофа числа и Прандтля числа:

$$Ra = Gr \cdot Pr.$$

Смысл введения Р. ч. наряду с числом Грасгофа при рассмотрении свободноконвективного теплообмена связан с тем обстоятельством, что, как показывают численные решения ур-ний вязкой теплопроводной среды и прямые эксперим. исследования, для газов и металлов жидкостей безразмерный коэф. теплообмена — Нуссельта число (Nu) — определяется именно произведением чисел Грасгофа и Прандтля, т. е.

$$Nu = f(Ra).$$

В большинстве случаев такая зависимость имеет вид безразмерной ф-ции $Nu = c Ra^a$. При этом показатель степени a зависит от режима течения в среде, опреде-

ляемого Р. ч., а коэф. c также от геометрии рассматриваемой системы. Р. ч. широко используется при описании процессов теплообмена, происходящих на борту космич. аппаратов при орбитальном полёте, т. е. в условиях микрогравитации.

Лит.: Теория теплообмена. Терминология, М., 1971; Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике, М., 1975.

РЭЛЁН — ДЖИНСА ЗАКОН ИЗЛУЧЕНИЯ — закон распределения энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела в зависимости от темп-ры:

$$u_\omega = (8\pi \nu^3 / c^3) k T,$$

где u_ω — плотность излучения на частоте ν . Р.—Д. з. и. выведен Дж. У. Рэлеем (J. W. Rayleigh) в 1900 из классич. представлений о равномерном распределении энергии по степеням свободы. В 1905—09 Дж. Джинс (J. Jeans), применив методы классич. статистики физики к волнам в полости, пришёл к той же ф-ле, что и Рэлей. Р.—Д. з. и. хорошо согласуется с экспериментом лишь для малых ν (в ДВ-области спектра). С ростом ν энергия излучения по Р.—Д. з. и., вопреки опыту, должна неограниченно расти, достигая чрезвычайно больших значений в дальней УФ-области спектра (т. н. У Ф - к а т а с т р о ф а). Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела, справедливое для всего спектра, получается только на основе квантовых представлений и описывается Планка законом излучения, частным случаем к-рого и является Р.—Д. з. и. Применяют Р.—Д. з. и. при рассмотрении ДВ-излучения, когда не требуется высокая точность вычислений.

Лит.: Ш а н я н К. М., Теория теплового излучения, пер. с нем., Л.—М., 1935; Б о р н М., Атомная физика, пер. с англ., 3 изд., М., 1970.



САВАР — устаревшая единица частотного интервала. Названа в честь Ф. Савара (F. Savart). 1 С. равен частотному интервалу с таким отношением f_2/f_1 граничных частот, что $\lg f_2/f_1 = 0,001$; при этом $f_2/f_1 = 1,0023$. 1 С. = $3,32 \cdot 10^{-3}$ октавы = 3,98 цента. Применяется для измерения интервалов высоты звука.

САДОВСКОГО ЭФФЕКТ — возникновение вращат. механич. момента у тела, облучаемого эллиптически поляризованным светом. Как показал впервые А. И. Садовский (1888), эллиптически поляризованная световая волна обладает моментом импульса, плотность потока к-рого в вакууме равна: $M = |E \times A| = I/q\omega$, где I — яркость светового пучка (модуль вектора Поинтинга), q — степерь эллиптичности (см. Стожа параметры), ω — угл. частота световой волны, E — напряжённость её электр. поля, A — вектор-потенциал эл.-магн. поля волны. С квантовой точки зрения существование момента импульса световой волны связано с тем, что при эллиптич. поляризации вероятности ориентации спина фотона в направлении его движения и навстречу ему не одинаковы (для одного фотона $M = h/2\pi$). Величина С. э. очень мала. Так, для видимого света ($\omega = 4 \cdot 10^{16} \text{ с}^{-1}$), поляризованного по кругу ($q = 1$) и по яркости равного яркости прямого света Солнца, $M = 3 \cdot 10^{-19}$ дин·см. Для поляризованного по кругу сантиметровых волн ($\omega = 10^{10} \text{ с}^{-1}$) $M = 10^{-3}$ дин·см при $I = 1 \text{ Вт/см}^2$. Несмотря на это, С. э. наблюдался экспериментально как для видимого света, так и для сантиметровых волн. Особенно большую роль С. э. играет в процессах излучения и поглощения света атомами и молекулами, где его существование в значит. степени

определяет правила квантования (напр., правила Бора, см. *Атомная физика*).

С теоретич. точки зрения, существование С. з. позволяет применять к явлению взаимодействия эл.-магн. волн с веществом закон сохранения момента количества движения.

Лит.: Соколов А. А., Введение в квантовую электродинамику, М., 1958; Розенберг Г., Наблюдение спинового момента сантиметровой волны, «ФОН», 1950, т. 40, в. 2, с. 328.

САМАРИЙ (лат. Samarium), Sm, — хим. элемент III группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 62, ат. масса 150,36, относится к лантаноидам. Природный С. — смесь 7 изотопов: ^{144}Sm , ^{147}Sm — ^{148}Sm , ^{152}Sm , ^{154}Sm , в к-рой преобладает ^{152}Sm (26,7%), а наименее предвлетает ^{144}Sm (3,1%). ^{147}Sm и ^{148}Sm α -радиоактивны ($T_{1/2} = 1,06 \cdot 10^{11}$ и $7 \cdot 10^{13}$ лет соответственно). Электронная конфигурация внеш. электронных оболочек $4f^2 6s^2 4d^1 6p^6 5d^2 6s^2$. Энергии последовательной ионизации 5,63; 11,07; 23,4 эВ соответственно. Металл. радиус атома Sm 0,181 нм, радиус иона Sm^{3+} 0,097 нм. Значение электроотрицательности 1,07.

В свободном виде серебристый металл. При низких темп-рах устойчив α -Sm с ромбоэдр. кристаллич. структурой, параметры решетки $a = 0,3626$ нм и $c = 2,618$ нм. При высоких темп-рах устойчив β -Sm с объемноцентрированной кубич. структурой с параметром решетки $a = 0,407$ нм. Темп-ра перехода $\alpha \rightarrow \beta$ 917°C (по др. данным, 855°C). Плотность α -Sm 7,537 кг/дм 3 , β -Sm 7,40 кг/дм 3 , $t_{пл} = 1072$ К, $t_{кип}$ ок. 1800°C. Уд. теплотопкость $c_p = 29,5$ Дж/(моль·К), теплота плавления 8,61 кДж/моль. Темп-ра Дебая 148 К. Теплопроводность металла. Sm 13,3 Вт/(м·К), коэф. линейного расширения $10,4 \cdot 10^{-6}$ К $^{-1}$ (при 298 К). Уд. электр. сопротивление 1,05 мОм·м (при 293 К), термич. коэф. электр. сопротивления $1,48 \cdot 10^{-4}$ К $^{-1}$ (при 273—373 К). С. — парамагнетик, магн. восприимчивость $8,49 \cdot 10^{-6}$ тл. по Бриеллю С. чистой 99,5% 343—441 МПа, модуль нормальной упругости 34,1 ГПа, модуль сдвига 126,5 ГПа.

В соединениях проявляет степень окисления +3 и, реже, +2. По хим. свойствам аналогичен др. легким лантаноидам. Интерметаллич. соединения SmCo $_5$ характеризуются высокими точкой Кюри (997 К) и магнитной насыщенности (0,965 Тл при комнатной темп-ре) и используются как материал пост. магнитов. Металл С. применяют для изготовления электр. стартеров С. характеризуется высоким эфф. сечением захвата тепловых нейтронов (для природного С. $5,6 \cdot 10^{-28}$ м 2 для ^{149}Sm $5 \cdot 10^{-24}$ м 2), поэтому его используют в нейтронных детекторах. В качестве радиоакт. индикатора применяется β -радиоактивный ^{153}Sm ($T_{1/2} = 46,7$ ч). С. с. Бердников.

САМОВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ — самопроизвольное (без внеш. воздействий) возникновение колебаний в колебат. системе при неустойчивом состоянии равновесия последней. С. к. происходит под влиянием малых нач. отклонений системы от состояния равновесия, неизбежно существующих вследствие флуктуаций; возникшие колебания нарастают, и в системе могут установиться автоколебания, к-рые поддерживаются за счёт энергии того или иного источника.

САМОВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛН — изменение характеристик волнового процесса вследствие взаимного влияния разл. волновых явлений в среде. В узком смысле термин «С. в.» применяется к однокомпонентным системам с безинерционной нелинейностью. Рассмотрим, напр., ур-ние для простых волн:

$$u_t + (V + u)u_x = 0. \quad (1)$$

Решение этого ур-ния задается неявным соотношением: $u(x, t) = -V + u_0(x - (u(x, t) + V)t)$ с нач. условием $u(x, t = 0) = u_0(x)$. Пока нелинейные эффекты малы, $|u| \ll V$, это решение принимает вид: $u(x, t) = u_0(x - Vt)$. Следовательно, волна распростра-

няется без искажения формы и с пост. групповой скоростью V . В общем случае $u_0 \neq \text{const}$ решение Коши задачи для ур-ния (1) существует только в течение конечного времени: рост нелинейности (слагаемого uu_x) ведёт к деформации профиля волны, а в дальнейшем — к её опрокидыванию. Аналогично в случае нелинейного ур-ния теплопроводности

$$T_t = \nabla^2(T \nabla T) + T^3 \quad (2)$$

при $\beta > 0$ + 1 решение существует конечное время (т. н. время обострения), в течение к-рого возникает локализованная структура с убывающей шириной и неограниченно растущей амплитудой.

Как правило, в физ. задачах конечность времени существования или неограниченный рост решения связаны с пренебрежением к-л. эффектами. Если, напр., учесть диссипативные процессы, добавив в правую часть (1) слагаемое au_{xx} , $a > 0$:

$$u_t + (V + u)u_x = au_{xx} \quad (3)$$

(Бюргерса уравнение), то в этом случае конкуренция нелинейного увеличения крутизны профиля и его диссипативного сглаживания может давать решения с неизменным во времени профилем — ударную волну с конечной толщиной фронта. Кроме того, возникнут решения с убывающей амплитудой.

В примерах (1), (2) С. в. вело к эффектам типа опрокидывания фронта или к обострению профиля. Однако в ряде случаев именно нелинейные процессы ограничивают развитие неустойчивости. Напр., обобщённое ур-ние Гинзбурга — Ландау

$$u_t = -u_{xxxx} - 2u_{xx} + (\beta - 1)u - u^3 \quad (4)$$

при $0 < \beta < 1$ имеет единственное однородное решение: $u = 0$, к-рое неустойчиво по отношению к возмущениям типа $\sim \exp(ikz)$ с волновыми векторами $k \in (\sqrt{1 - \beta}, \sqrt{1 + \beta})$. С. в., описываемое слагаемым $(-u^3)$ в (4), ограничивает рост амплитуды возмущений, и в системе устанавливается стационарная пространственно-периодич. структура.

Строго говоря, однокомпонентные системы с самовоздействием — это приближённое описание многокомпонентных систем, в к-рых характерные времена эволюции разл. степеней свободы сильно различаются. Напр., в нелинейной оптике безинерционная нелинейность для сильной световой волны формирует быстрыми процессами в среде, индицируемых самой световой волной. В общем случае временем задержки отклика среды на волновой процесс пренебрегать нельзя. При этом говорят об инерционной нелинейности или о нелинейной многокомпонентной системе. Пример — ур-ние Курамото — Судзуки (двухкомпонентная система):

$$w_t = w + (1 + iC_1)w_{xx} - (1 + iC_2)|w|^2 w, \quad (5)$$

описывающее поведение многих систем в окрестности бифуркац. значений параметров (см. Бифуркация). Здесь w — комплекснозначная ф-ция, а C_1 и C_2 — действительные числа. При подходе к выбору коэффициентов ур-ние (5) допускает как простейшие, стационарные решения, так и более сложные, вплоть до стохастических (т. н. диффузионный хаос). Конкуренция диссипативных процессов и эффектов С. в. (в указанном смысле) ведёт к усложнению динамики системы. Физ. пример инерционного С. в. — тепловая дефокусировка лазерного излучения, обусловленная изменением показателя преломления среды при её нагреве излучением (см. Самовозбуждение света).

Лит.: Квчмарек Ф., Введение в физику лазеров, пер. с польск., М., 1981; Магнетическое зондирование. Сб. ст., М., 1988. В. А. Сидяев, В. А. Рожановская Ю. М. Яхно И. В. Г. Автономные процессы, М., 1987; Заславский Г. М., Сагдеев Р. З., Введение в нелинейную физику, М., 1988. Н. А. Гырченко.

САМОВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА — эффекты изменения характера распространения света в нелинейной среде, обусловленные зависимостью свойств среды от его интенсивности. Существуют два типа С. с., связанные с разл. влиянием мощного оптич. излучения на показатель преломления. В одном случае в нелинейной среде показатель преломления n (его действит. часть) является ф-цией интенсивности I и волна бежит с др. фазовой скоростью v , чем в линейной среде: $v = c/n(I)$. В поле ограниченной волны такая среда становится неоднородной и возникает явление нелинейной рефракции (искривления) лучей, приводящее к *самофокусировке света* или *самодефокусировке света*. При прохождении через нелинейную среду волнового пакета (импульса) возникает самомодуляция фазы, к-рая при наличии дисперсии переходит в амплитудную. Фазово-модулированный импульс может испытать компрессию или деконпрессию. Благодаря самодействию оптич. импульсы могут распространяться в диспергирующей среде без распада в виде *солитонов* оптических. В кристаллах имеет место нелинейное вращение плоскости поляризации (см. *Нелинейная оптическая активность*).

Др. тип С. с. связан с нелинейным изменением мнимой части показателя преломления, т. е. с нелинейным поглощением. Оно может иметь квантовую природу — это двух-, трех- и в общем случае *многофотонное поглощение*. В облачной среде оно связано с нагревом и испарением аэрозолей, с фотоионизацией поглощающих молекул и т. д. При нелинейном поглощении меняется закон затухания амплитуды волн с пройденным расстоянием (по сравнению с *Бузера — Ламберта — Бера законом*). Большой интерес представляют случаи индуцированного излучения просветления поглощающих сред (см. *Самоионизирующая прозрачность*).

А. П. Сухоруков.

САМОВЫСТРАИВАНИЕ — *выстраивание ансамблей атомов и молекул, образующиеся без внеш. воздействий*, а в результате, напр., *пленения излучения* (в плазме) и соударения частиц. И то и другое может быть по разным причинам анизотропным, что приводит к С. атомов (молекул) в определ. квантовых состояниях.

При пленении излучения его анизотропия приводит к выстраиванию состояния, возбужденного этим излучением. В произвольной точке объема, занятого плазмой, можно выделить два направления с экстремальными интенсивностями излучения (в цилиндрчик, разрядной трубке оно максимально параллельно оси, а в направлении, перпендикулярном оси и радиусу трубки, оно минимально) и наведенное им С. будет двусосным. Оно описывается тензором, гл. оси к-рого совпадают с осями симметрии распределения излучения. Ни в какой системе координат двусосное С. нельзя описать равнолюк вращением земазовских подуровней, в матрице плотности всегда останутся «когерентные» члены, связывающие состояния с разными маг. числами m . Но на оси трубки С. одноосно и его можно свести к продольному выстраиванию, адекватному разности заселенностей земазовских подуровней.

Ещё один вид С. — скрытое выстраивание, связанное с тепловым движением частиц. Благодаря этому движению вероятность взаимодействия с излучением и вероятность столкновений для каждой частицы имеют неаизотропное осесимметричное распределение, и в результате ансамбль атомов с заданным направлением теплового движения может оказаться выстроенным. В ср. по всему объёму скрытое С. не проявляется вследствие хаотичности теплового движения. Тем не менее локальное скрытое С. оказывает влияние на контур излучения (поглощения) спектральной линии, а через это — на количеств. характеристики пленения излучения и заселенности уровней.

С., как и выстраивание вообще, разрушается магн. полем, не параллельным оси выстраивания (*Хамле эф-*

фект). При этом меняются поляризац. характеристики излучения, а иногда и интенсивность. Эти изменения образуют т. н. сигналы выстраивания, позволяющие определять константы релаксации — радиацион. распада, столкновит. разрушения выстраивания и др.

С. впервые было зарегистрировано в тлеющем разряде; его наблюдали также в короне и протуберанцах Солнца. Изучение поляризац. характеристик солнечного излучения позволило найти распределение магн. поля в солнечных пятнах и проследить за его изменением.

С. атомов наблюдалось в возбужденных состояниях, но оно возможно и в осн. состоянии. Однако осн. состояние аниат. части атомов элементов таблицы Менделеева не удовлетворяют необходимому для выстраивания условию, согласно к-рому квантовое число угл. момента должно быть не меньше единицы. См. также ст. *Интерференция состояний* и лит. при ней.

Лит.: Алек. Андров Е. Б., Хвостенко Г. И., Чаяка М. П., *Интерференция атомных состояний*, М., 1991, М. П. Чаяка.

САМОДЕФОКУСОВКА СВЕТА — нелинейное распыливание высокочастотного светового пучка, распространяющегося в нелинейной среде, показатель преломления к-рой уменьшается с ростом интенсивности поля:

$$n = n_0 + n_{\text{нд}}(|A|^2), \quad n_{\text{нд}} < 0. \quad (1)$$

Здесь A — комплексная амплитуда поля, n_0 — линейная часть показателя преломления среды, $n_{\text{нд}}$ — отрицат. нелинейная добавка к показателю преломления, конкретный вид к-рой зависит от механизма нелинейности среды. Если нелинейная добавка к показателю преломления положительная ($n_{\text{нд}} > 0$), то вместо дефокусировки развивается *самофокусировка света*.

При падении светового пучка, имеющего, напр., гауссово распределение амплитуды по поперечной координате r шириной a ,

$$A = E_0 \exp(-r^2/a^2), \quad (2)$$

нелинейная среда с показателем преломления (1) становится оптичски неоднородной. В такой среде лучи испытывают нелинейную рефракцию, отклоняясь в области больших значений показателя преломления, а именно, от осн пучка к периферии. Это и приводит к С. с., а слой нелинейной среды играет роль отрицат. (рассеивающей) линзы с фокусным расстоянием $F_{\text{нл}}$, зависящим от интенсивности (мощности) пучка. В зависимости от соотношения между фокусным расстоянием $F_{\text{нл}}$ и толщиной среды l , к-рому проходит свет, различают два случая — тонкой и толстой линзы.

Тонкая нелинейная линза. Если $F_{\text{нл}} > l$, то рефракция лучей внутри слоя мала (рис. 1), сечение пучка

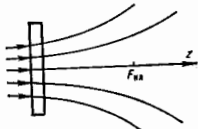


Рис. 1. Траектории лучей при самодефокусировке в тонкой нелинейной линзе.

при прохождении среды остается неизменным, а меняется лишь волновой фронт. В толстом слое происходит нелинейный набег фазы:

$$\Phi_{\text{нл}} = k_0 n_{\text{нд}} \left(E_0^2 \exp(-2r^2/a^2) \right), \quad (3)$$

где $k_0 = \omega/c$ — волновое число в вакууме, ω — частота.

Для гауссова пучка ф-ция $\Phi_{\text{нл}}$ представлена на рис.

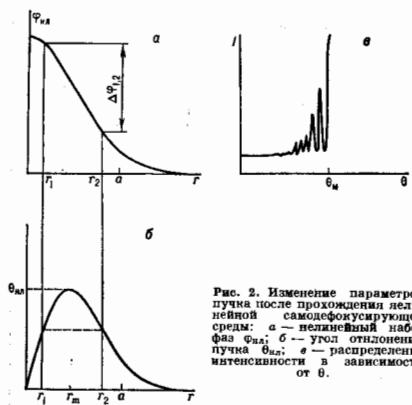


Рис. 2. Изменение параметров пучка после прохождения нелинейной самодефокусирующей среды: а — нелинейный набег фаз $\Delta\varphi$; б — угол отклонения пучка θ ; в — распределение интенсивности в зависимости от z .

2, а. Лучи выходят из слоя под разными углами $\theta_{\text{нл}}$ (рис. 2, б):

$$\theta_{\text{нл}}(r) = \frac{1}{k_0} \frac{\partial \Phi_{\text{нл}}}{\partial r} = l \frac{\partial n_{\text{нл}}}{\partial r}. \quad (4)$$

Наиб. отклонение испытывают лучи, выходящие из области макс. градиента изведённой поперечной неоднородности показателя преломления, расположенной на $r_m = a/2$. Под меньшими углами $\theta < \theta_{\text{нл}}$ вдоль каждого направления идут два луча, интерферирующие между собой на большом удалении от нелинейной среды. В зависимости от разности фаз этих лучей $\Delta\varphi$ под к.-л. данным углом может наблюдаться минимум или максимум амплитуды — возникает характерная кольцевая структура (рис. 2, в, и рис. 4, а). Это явление наз. в нелинейном абберации.

Первое тёмное кольцо образуется при $\Delta\varphi = \pi$, второе — при $\Delta\varphi = 3\pi$ и т. д. Второе светлое кольцо (внутри внеш. светлого кольца с угла расходимости $\theta_{\text{нл}}$) образуется при $\Delta\varphi = 2\pi$, а последующие — при $\Delta\varphi = 2k\pi$. Т. о., число дополнит. светлых колец в абберак. картине дефокусировки равно

$$N = |\Phi_{\text{нл}}(0) - \Phi_{\text{нл}}(\infty)| / 2\pi = |n_{\text{нл}}(E_0^2)| / \lambda_0. \quad (5)$$

Угл. расходимость дефокусированного пучка определяется ф-лой

$$\theta_{\text{нл}} = \theta(r_m) \approx 1,3 n_{\text{нл}}(E_0^2) l / a \approx 4N \theta_{\text{диф}}, \quad (6)$$

где $\theta_{\text{диф}} = 2/ka$ — дифракционная расходимость гауссова пучка.

Топку нелинейную линзу удобно характеризовать фокусным расстоянием:

$$F_{\text{нл}} = a / \theta_{\text{нл}} \approx a^2 / n_{\text{нл}} l \approx l_n / 4N, \quad (7)$$

где $l_n = ka^2/2$ — дифракц. длина пучка или протяжённость зоны Френеля дифракции.

Т. о., с увеличением мощности пучка растёт его интенсивность E_0^2 на осп, растут $n_{\text{нл}}$ и $\theta_{\text{нл}}$, т. е. усиливается эффект дефокусировки. Чем больше расходимость пучка, тем больше число абберак. колец N . Дефокусировка пучка выражается в том, что с ростом мощности пучка амплитуда и интенсивность уменьшаются, а появление каждого нового тёмного кольца со-

провождается изменением интенсивности в центре пучка в дальнем поле.

Толстая нелинейная линза. В толстом слое нелинейной среды пучок значительно расширяется уже внутри самого слоя и эффективная (интенсивная) дефокусировка идёт на расстоянии порядка $F_{\text{нл}} \ll l$. Для оценки $F_{\text{нл}}$ толстой линзы можно воспользоваться ф-лой (7), заменив толщину слоя l на $F_{\text{нл}}$, получая в результате выражение

$$F_{\text{нл}} = a \sqrt{n_0 / n_{\text{нл}}(E_0^2)}. \quad (8)$$

Нелинейная расходимость пучка при внутр. дефокусировке, т. е. и толстом слое, равная $\theta_{\text{нл}} = \sqrt{n_{\text{нл}} / n_0}$ слабее зависит от мощности пучка, чем в тонком слое (6). Заметная дефокусировка наблюдается при $\theta_{\text{нл}} \approx \theta_{\text{диф}}$ отсюда можно определить порог этого эффекта.

На практике наиб. часто осуществляется тепловая С. с., обусловленная появлением $n_{\text{нл}}$ при нагреве среды в результате поглощения доли энергии светового пучка, $n_{\text{нл}} = (T - T_0) dn/dT$, где T_0 — равновесная темп-ра, T — темп-ра после нагрева, к-рая находится из ур-ния теплопроводности:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + v \frac{\partial T}{\partial x} \right) = \kappa \Delta T - \frac{c n_0}{8\pi} |A|^2, \quad (9)$$

где ρc_p — уд. теплоёмкость, κ — коэф. теплопроводности, α — коэф. поглощения, v — скорость конвективного движения среды (или пучка относительно среды) в направлении, перпендикулярном световому пучку вдоль оси x (рис. 3).

Рис. 3. Самоотклонение светового пучка навстречу поперечному движению нелинейной дефокусирующей среды.



Тепловая линза имеет конечное время релаксации, определяемое теплопроводностью в пучке $\tau_T = \rho c_p a^2 / \kappa$. Короткие импульсы ($\tau \ll \tau_T$), для к-рых $n_{\text{нл}} \approx \alpha |A|^2 dt$, испытывают нестационарную С. с., пропорциональную поглощённой энергии, а длинные ($\tau \gg \tau_T$) импульсы и непрерывное излучение — стационарную, $n_{\text{нл}} \approx \alpha E_0 a^2 / \kappa$. Кроме того, резко различаются случаи неподвижной среды ($v = 0$) и среды с поперечной конвекцией.

При стационарной тепловой дефокусировке в толстом неподвижном слое углы расходимости, фокусное расстояние и число дополнит. светлых колец определяются ф-лами, следующими из (5) и (6):

$$\theta_{\text{нл}} = \alpha \frac{dn}{dT} E_0^2 a l / \kappa, \quad F_{\text{нл}} = \kappa / \alpha \frac{dn}{dT} E_0^2 l, \quad N = \alpha \left| \frac{dn}{dT} \right| E_0^2 a^2 l / \lambda_0 \kappa. \quad (10)$$

В толстом слое слабопоглощающей среды параметры дефокусированного пучка

$$F_{\text{нл}} \approx (\kappa / \alpha) \left| \frac{dn}{dT} \right| E_0^2 l / 2, \quad \theta_{\text{нл}} = a \left(\alpha \left| \frac{dn}{dT} \right| E_0^2 / \kappa \right)^{1/2}. \quad (11)$$

Ф-лы (10) и (11) можно получить с помощью теории подобия и размерностей, придан им вид универсальных законов. При переходе от гауссова пучка к др. пучкам изменяются только численные коэффициенты.

В движущейся дефокусирующей среде ($n_{\text{нл}} < 0$) тепловая дефокусировка проявляется в самоотклонении светового пучка при $\partial n / \partial T < 0$ навстречу поперечному потоку в более холодную часть

среды (рис. 4,б). (В среде с $\partial n/\partial T > 0$ пучок отклоняется в направлении потока.) Относительный вклад конвекции в термодиффузию в теплопередачу характеризуется числом Пекле: $\gamma = \rho c_p \nu/k$. При малых числах Пекле

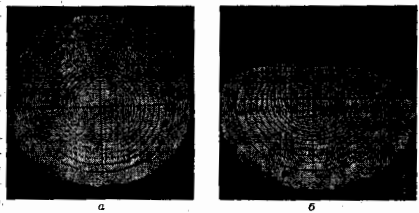


Рис. 4. Тепловая самофокусировка пучка света аргонового лазера мощностью 60 мВт: а — после прохождения линзы с выходным светом; б — отклонение пучка вправо к движущейся среде (стрелкой показано направление движения среды).

вклад конвективного теплопереноса незначителен и С. с. идёт практически так же, как и в неподвижной среде: центр пучка смещается на малый угол, пропорциональный скорости течения; $\theta_{\text{откл}} \propto \nu \partial n/\partial T \propto \nu$. Если скорость поперечной конвекции становится большой, то в выносе тепла из области пучка в направлении оси x ось. роль играет конвекция [член $\nu \partial T/\partial x$ в ур-нии (9)] и распределение температуры среды по поперечному сечению пучка становится несимметричным. В результате этого пучок смещается по оси x на угол $\theta_{\text{откл}} \propto \nu \partial n/\partial T \propto \nu^{-1}$, к-рый сравним или даже больше угла дефокусировки. Поперечное сечение пучка на расстоянии приобретает характерную серповидную форму (рис. 3).

Тепловая С. с. является одним из осн. эффектов в оптике атмосферы. Она ограничивает предельные возможности передачи большой энергии или мощности на большие расстояния с помощью волновых пучков. В то же время тепловая С. с. используется в нелинейной спектроскопии, в частности для измерения коэф. поглощения α , скорости движения среды ν , коэф. теплопроводности k на основе измерения взаимности угла расхождения $\theta_{\text{откл}}$ угла самоотклонения $\theta_{\text{откл}}$ от этих параметров α, ν, k и др.

Более сложный вид С. с. приобретает в твёрдых телах из-за появления термоупругих напряжений, введённого двулучепреломления и т. д.

Лит.: А. К. Шапов С. А., К. В. Кольцов Р. В., Sukhorukov A. P. Self-focusing, self-defocusing and self-modulation of laser beams, в кн.: Laser handbook, v. 2, Amst., 1972, p. 1151; Виноградов М. В., Руде и др. О. В., С. Угрюмов А. П., Теория волн, 2 изд., М., 1990.

САМОДИФФУЗИЯ — частный случай диффузии в чистом веществе или растворе пост. состава, при к-рой диффундируют собств. частицы вещества. При С. атомы, участвующие в диффуз. движении, обладают одинаковыми хим. свойствами, но могут отличаться, напр., атомной массой, т. е. быть разными изотопами одного элемента. За процессом С. можно наблюдать, применяя радиоакт. изотопы или анализируя изотопный состав вещества на масс-спектрометре. Изменение изотопного состава в зависимости от времени описывается обычными ур-ниями диффузии, а скорость процесса характеризуется коэф. диффузии. Диффуз. перемещение частиц твёрдого тела могут приводить к изменению его формы и др. явлениям, если на тело длительно действуют силы поверхностного натяжения, тяжести, упругости, электрич. силы и др. При этом наблюдаются сраствание прилиффованных образцов одного и того же вещества, спекание порошков, растрескивание тел под действием подвешенного к ним груза (диффуз. ползуемость материалов) и т. д. Изучение кинетики этих процессов позволяет определить коэф. С. вещества.

Лит. см. при ст. Диффузия.

САМОИНДУКЦИЯ (явление) — наведение вихревых электрич. полей в проводящих телах при изменении токов в этих же телах или их деформациях. Подробнее см. *Электромагнитная индукция*.

САМОИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ — эффект прохождения коротких мощных импульсов когерентного оптич. излучения без потерь энергии через среду, резонансно поглощающую непрерывное излучение или длинные импульсы. С. п. относится к когерентным резонансным эффектам: её наблюдение возможно только при условии, что длительность импульса ($\tau_{\text{и}} \ll \tau_{\text{р}}$) значительно меньше времени релаксации (для разреженных газов $\sim 10^{-7}$ – 10^{-9} с, для конденсиров. сред $\sim 10^{-11}$ – 10^{-12} с). В этом случае релакс. процессы не успевают нарушить фазовые соотношения между полем и нестационарным резонансным откликом вещества, вследствие чего энергия, поглощённая средой на переднем фронте импульса с достаточной высокой интенсивностью, может быть полностью возвращена импульсу на его заднем фронте за счёт процессов индуктирования. Тем самым С. п. принципиально отличается от просветления среды, связанного с некогерентным эффектом насыщения — выравниванием заселённости основного и возбуждённого состояний (см. *Просветляющий эффект*). Эффект С. п. был предсказан С. Л. МакКаллом (McCall S. L.) и Э. Ханом (E. Hahn) в 1965 и наблюдался ими в 1967.

Возможность проявления С. п. обусловлена колебат. характером динамики квантовых переходов в резонансном поле в отсутствие релаксации (т. е. в течение времени $< \tau_{\text{р}}$, см. *Двухуровневая система*). Частицы вещества, первоначально находившиеся в ниж. энергетич. состоянии $|a\rangle$, под действием импульса когерентного ал.-магн. излучения, частота к-рого совпадает с частотой перехода между квантовыми уровнями a и b , переходят в когерентную суперпозицию состояний $|a\rangle$ и $|b\rangle$, поглощая при этом часть энергии поля. Т. к. предположительно когерентность взаимодействия не нарушается релаксат. процессами (т. к. $\tau_{\text{и}} \ll \tau_{\text{р}}$), то в определённый момент частицы оказываются в верх. состоянии $|b\rangle$, а затем постепенно переходят в ниж. состояние $|a\rangle$, возвращая поля в процессе индуктированного испускания запасённую ранее энергию. Под действием последующих частей импульса процесс обмена энергией между полем и веществом повторяется. Если амплитуда и длительность импульса таковы, что по его окончании все резонансные частицы оказываются в исходном невозбуждённом состоянии, то такой импульс проходит через среду без потери своей энергии.

В оптических тонких средах влияние вещества на поле невелико: оно сказывается лишь в небольшом изменении формы импульса. В частности, возможно появление глубокой амплитудной модуляции с частотой Раби, определяемой амплитудой импульса на входе в среду (см. *Оптическая нутация*).

Эффект С. п. возникает в оптических плотных средах, когда влияние вещества на поле значительно, и представляет собой один из возможных режимов когерентного распространения коротких импульсов в резонансных средах. Его простейшее описание основано на использовании волнового ур-ния для медленно меняющейся амплитуды электрич. поля импульса $A(t, z)$ (полное поле $E = A \exp[-i(\omega t - kr)] + \text{к. с.}$) и ур-ний для матрицы плотности двухуровневой системы, записанных в предположении, что длительность импульса τ намного меньше времени продольной T_{\parallel} и поперечной T_{\perp} релаксации.

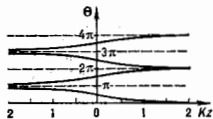
Режим прохождения импульса через резонансно поглощающую среду определяется его «локальным»

$$\theta(z) = \frac{2d_{ba}}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} A(z, t) dt,$$

где d_{ba} — матричный элемент электрич. дипольного момента двухуровневой системы. Параметр $\theta(z)$ «отра-

жает состояние среды в данной точке после прохождения импульса. В частности, при $\theta(z) = 2\pi l$ ($l = 0, 1, 2, \dots$) процесс обмена энергией между полем и веществом заканчивается возвратом резонансных частиц в исходное невозбужденное состояние. Для $\theta(z)$ справедливы т. н. теорема площадей, графическое представление к-рой дано на рис. 1. В случае, когда частота импульса

Рис. 1. Зависимость «площади» импульса θ от z . Для возбужденного образца θ развивается в направлении $-z$ (з измеряется в единицах λK^{-1}).



совпадает с центральной частотой ω_0 , симметричной неоднородно уширенной линии, «теорема площадей» выражается ф-лой

$$\theta(z) = 2 \arctg \left[\operatorname{tg} \frac{\theta_0}{2} \exp(-Kz/2) \right],$$

где θ_0 — значение θ на входе в среду; $K = 4\pi^2 N \omega_d^2 \operatorname{Re} g(0) / ch$, N — плотность резонансных частиц, $g(0)$ — значение ф-ды распределения $g(\omega_0 - \omega_{ba})$ собств. частот ω_{ba} в максимуме. Параметр K имеет смысл коэф. затухания слабых импульсов с $\theta \ll 1$.

Пропускание коротких импульсов средой зависит от их площади. При $\theta_0 \ll \pi$ импульсы затухают на расстоянии в неск. для поглощения, равных K^{-1} (рис. 1, 2, слева). Режим С. п. реализуется, если входная площадь импульсов превышает пороговое значение $\theta_0 = \pi$.

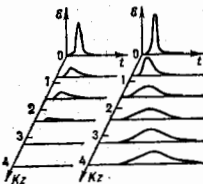


Рис. 2. Эволюция форм импульсов при распространении в поглощающей резонансной среде: слева — при $\theta = 0,9\pi$; справа — при $\theta = 1,1\pi$. Начальная форма импульса — гауссова.

В этом случае по мере распространения импульса «площадь» его $\theta(z)$ стремится к ближайшему стабильному значению $2\pi l$ ($l = 1, 2, 3, \dots$), т. е. формируются т. н. $2\pi l$ -импульсы, проходящие через среду без потерь.

При $\pi < \theta_0 < 3\pi$ на расстояниях порядка неск. для поглощения формируются стационарные $2\pi l$ -импульсы, имеющие симметричную форму, к-рая при дальнейшем распространении не изменяется (рис. 2, справа). Такие импульсы представляют собой солитоны оптической среды. Форма солитона определяется ф-лой

$$A = \frac{\eta}{d_{\text{эф}}} \operatorname{sech} \left[\tau^{-1}(t - z/v) \right],$$

где v — групповая скорость распространения стационарного импульса, связанная с длительностью импульса τ ; в отсутствие неоднородного уширения линии поглощения эта связь выражается ф-лой

$$v = c \left(1 + 4\pi^2 N \omega_d^2 \frac{\tau^2 \hbar^{-1}}{d_{\text{эф}}} \right)^{-1}.$$

Видно, что стационарные импульсы «бегут» со скоростью, меньшей скорости света с. Значение v уменьшается с увеличением коэф. поглощения K и длительности импульса и может отличаться от с на $3-4$ порядка. Это замедление импульсов обусловлено пост. эфф. обменом

энергией между полем и веществом и является характерной особенностью С. п.

Если $\theta_0 > 3\pi$, то одиночные входные импульсы разбиваются на соответствующее кол-во субимпульсов, что можно трактовать как процесс разбегания солитонов, каждый из к-рых в отдельности является $2\pi l$ -импульсом.

Следует отметить, что при $\theta_0 < \pi$ в зависимости от формы входного импульса возможно формирование т. н. 0л-импульсов, нулевое значение площади к-рых достигается не за счёт поглощения всей энергии поля, а вследствие скачкообразных изменений фазы внутри импульса.

Проявление эффекта С. п. возможно и при двухфотонном поглощении, когда сумма частот падающего излучения $\omega_1 + \omega_2$ совпадает с частотой двухфотонного перехода в веществе ω_{ba} (см. *Многофотонное поглощение*). Напр., в вырожденном по частоте случае $2\omega = \omega_{ba}$

при условии $\sqrt{4Q^2 d_{\text{эф}} + q^2} A^2(t) dt > \pi$ формируются импульсы, к-рые при распространении в среде не теряют своей энергии, однако длительность их всё время сокращается при соответствующем возрастании интенсивности. [Здесь $Q d_{\text{эф}}$ — матричный элемент двухфотонного перехода, q — константа динамич. итаргонского сдвига частоты перехода, вызываемого электрич. полем импульса (см. *Итаргон эффект динамический*)].

Эксперим. критериями С. п. являются: пороговое возрастание прочности среды при увеличении интенсивности падающих импульсов, наличие временной задержки выходящих импульсов и разбегание на субимпульсы при достаточно высоких значениях интенсивности.

Эффект С. п. наблюдался экспериментально в твёрдых телах и в газах [3].

С. п. представляет большой интерес для нелинейной оптики резонансных сред, физики солитонов, лазерной спектроскопии (в частности, для определения величин матричных элементов квантовых переходов).

Лит.: 1) М. с. С. А. 118, Л. Н. А. в. Е. Л. Coherent light propagation through an inhomogeneously broadened 2-level system, *Bull. Amer. Phys. Soc.*, 1965, v. 10, № 9, p. 1189; 2) и т. же, Self induced transparency by pulsed coherent light, *Phys. Rev. Lett.*, 1967, v. 18, p. 908; 3) А. Л. е. Л. В. Берля, М., Оптический резонанс и двухуровневые атомы, пер. с англ., М., 1978; 4) Полулятов И. А., Попов Ю. М., Ройзберг В. С., Эффект самоиндуцированной прозрачности, *УФН*, 1974, т. 114, с. 97. К. Н. Дробочев.

САМОМОДУЛЯЦИЯ СВЕТА — самоиндуцированная фазовая или амплитудная модуляция (в пространстве или во времени) высокоинтенсивного оптич. излучения, распространяющегося в нелинейной среде. При падении на среду плоской монохроматич. волны самоиндуцированной развивается вследствие *параметрической неустойчивости*, в результате чего световой пучок разбивается на множество тонких нитей или на серию стационарных импульсов. Если волна первоначально имеет неоднородный профиль интенсивности, то в нелинейной среде сначала появляется фазовая С. с., к-рая затем ведёт к нелинейной трансформации амплитудного распределения. Пространственная фазовая С. с. проявляется в искажении волнового фронта и приводит к *самофокусировке света* или *самодефокусировке света*, если среда имеет недостаточную протяжённость. Временная фазовая С. с. приводит к самокомпрессии и саморасширению импульса. Оптич. импульс $E = A \exp(i\omega t - k_0 z)$ с нач. амплитудным профилем $A(t, z=0) = E_0(t)$ (рис. 1, а) при распространении в нелинейной среде с показателем преломления $n = n_0 + n_2 |E|^2$ приобретает величайшую фазовую добавку (рис. 1, б):

$$\Phi_{\text{пл}} = -k_0 z n_2 E_0^2(t - z/v_0). \quad (1)$$

Здесь z — продвинутое расстояние, $v_0 = (\partial k / \partial \omega)^{-1}$ — групповая скорость на несущей частоте ω_0 , $k_0 = \omega_0 / c$ —

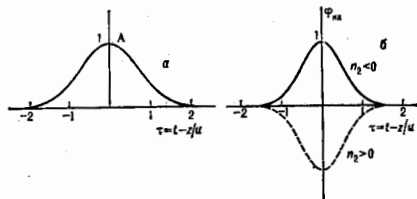


Рис. 1. Фазовая самомодуляция: а — амплитудный профиль; б — нелинейный набег фазы.

волновое число, n_2 — нелинейная добавка к показателю преломления. [Показатель преломления среды $n = n_0 + \Delta n(|E|^2)$, где $\Delta n(|E|^2)$ — наведённое световым полем изменение показателя преломления; если величинный отклик безынерционен, то $\Delta n(|E|^2) \equiv n_2|E|^2$. Мгновенная частота такого импульса меняется на величину (рис. 2, а)

$$\Delta\omega_{\text{нл}} = \partial\varphi_{\text{нл}}/\partial t = -k_0 n_2 z \partial E_0^2(t-z/u)/\partial t. \quad (2)$$

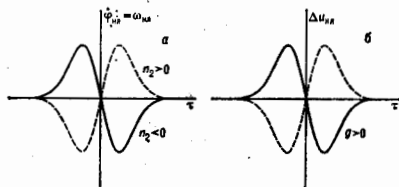


Рис. 2. Фазовая самомодуляция: а — нелинейная добавка к мгновенной частоте; б — нелинейная добавка к групповой скорости.

Фазовая модуляция при наличии зависимости показателя преломления $n(\omega)$ или фазовой скорости $v(\omega)$ от частоты вызывает амплитудную дивергенцию. Действительно, групповая скорость v в среде, обладающей заметной дисперсией, зависит от частоты:

$$v(\omega) = v(\omega_0) + \frac{\partial v}{\partial \omega_0}(\omega - \omega_0) + \dots, \quad \frac{\partial v}{\partial \omega_0} = -\frac{v}{\omega_0} \frac{\partial k}{\partial \omega_0}.$$

Т.о., в нелинейной диспергирующей среде разл. участки оптич. импульса имеют разные локальные групповые скорости, отличающиеся от групповой скорости в линейной среде на величину $\Delta v_{\text{нл}} = (\partial v/\partial \omega)\Delta\omega_{\text{нл}}$ (рис. 2, б), равную с учётом (2):

$$\Delta v_{\text{нл}} = k_0 z \frac{\partial}{\partial \omega_0} \left[\frac{\partial E_0^2}{\partial t} (t-z/u) \right], \quad g = n_2 \frac{\partial^2 k}{\partial \omega_0^2}. \quad (3)$$

Если огибающая импульса имеет колоколообразную форму, напр. гауссову (рис. 3, а), то в среде с $g > 0$ его фронт, где $\partial E_0^2/\partial t > 0$, распространяется быстрее его вершины, где $\partial E_0^2/\partial t = 0$, а хвост с $\partial E_0^2/\partial t < 0$ — медленнее, т.е. происходит расщепление импульса, с амплитудной компрессией (рис. 3, б). В среде с параметром $g < 0$ фронт идёт медленнее, а хвост быстрее вершины, вследствие чего происходит самоамплитудная компрессия импульса длительностью T_0 .

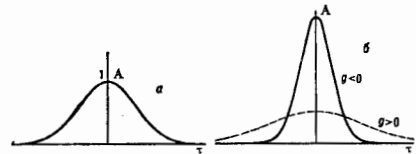


Рис. 3. а — начальный импульс; б — компрессия и деконпрессия.

расположена на таком расстоянии $l_{\text{нл}}$ от входа в среду, на к-ром хвост догоняет вершину:

$$\frac{l_{\text{нл}}}{v_0} - \frac{l_{\text{нл}}}{v_0 + \Delta v_{\text{нл}}} \approx T_0.$$

Отсюда при $\Delta v_{\text{нл}} \ll v_0$ длина самокомпрессии

$$l_{\text{нл}} = T_0 v_0^3 / \Delta v_{\text{нл}} = T_0 \left(-k_0 g E_0^2 \right)^{-1/2}. \quad (4)$$

В точке компрессии импульс сжимается до мин. длительности:

$$T_{\text{к}} = \frac{\partial^2 k / \partial \omega^2}{T_0 k_0 n_2 E_0^2}. \quad (5)$$

Для увеличения компрессии (т.е. получения малых $T_{\text{к}}$) часто выбирают две среды: первая с большой нелинейностью n_2 , чтобы получить большую $v_{\text{нл}}$, а вторая — с большой дисперсией нужного знака, $\partial^2 k / \partial \omega^2$. В точке компрессии образуется спектрально ограниченный импульс, обратная величина длительности к-ром равна частотной ширине импульса, вышедшего из нелинейной среды с фазой $\varphi_{\text{нл}}$.

Волна, имеющая пост. амплитуду E_0 , распространяется в нелинейной среде с фазовой скоростью $v_{\text{нл}} = c/(n_0 + n_2 E_0^2)$. Если среда имеет нелинейный дисперсионный параметр $g < 0$, то эта стационарная волна неустойчива, т.е. малые возмущения амплитуды и фазы в такой среде экспоненциально нарастают ($\sim \exp \Gamma$) и волна приобретает амплитудно-фазовую модуляцию.

Наиб. инкремент имеют временные возмущения с масштабом модуляции $T_{\text{н}}$, таким, что $T_{\text{н}} = T_0 = T_{\text{к}}$. Тогда из (5) следует:

$$T_{\text{н}} = \left[\frac{-n_2 (\partial^2 k / \partial \omega^2)^2}{n_2 k_0 E_0^2} \right]^{1/2}.$$

Т.о., стационарная волна разбивается на серию импульсов длительностью $T_{\text{н}}$.

Волновые пакеты в результате расщепления неустойчивости разбиваются на совокупность солитонов оптич. и ч.с.к.х., а волновые пучки — на отд. нити.

Лит.: Карман В. И., Нелинейные волны в диспергирующих средах, М., 1973; Ахьянов С. А., Вислюк В. А., Чиркин А. С., Оптика фемтосекундных лазерных импульсов, М., 1988.

САМООРГАНИЗАЦИЯ — самопроизвольное (не требующее внеш. организующих воздействий) установление в неравновесных диссипативных средах устойчивых регулярных структур (см. Диссипативные структуры). Первые исследования явления С. были проведены И. Р. Пригожиным и его коллегами в 1980-е гг. [1]. Процесс самопроизвольного формирования регулярных структур называют также процессом формообразования, а соответствующую область науки часто называют синергетикой [3].

Наиб. известный и наглядный пример С. — возникновение конвективных решёток (сотовой структуры конвекции) с шестигранными ячейками, ячейками

Бенара, при подогреве горизонтального слоя жидкости снизу (см. *Вифуркация*). При подогреве снизу плоского слоя жидкости развивается т. н. конвективная неустойчивость, связанная с тем, что молекулярный теплоперенос не в состоянии обеспечить температурный баланс между нагретой ниж. поверхностью и охлаждённой верх. поверхностью слоя. Всплывающий в результате действия архимедовой силы нагретый (более лёгкий) элемент жидкости вытесняет холодную жидкость, заставляя её двигаться вниз. В результате в слое устанавливается стационарное вращение элементов жидкости, к-рое при визуализации выглядит как структура упорядоченно вложенных рётиков или валов. Ориентация валов в достаточно большом горизонтальном слое произвольна и зависит лишь от случайных нач. условий. Характерный масштаб зависит от толщины слоя и параметров жидкости. В жидкостях, где существенна зависимость параметров от тем-ры, существующие на нач. этапе развития неустойчивости залы с разл. ориентацией в результате эффекта взаимной синхронизации образуют связанное состояние — решётку с шестигранными ячейками. Возбуждения с любыми др. масштабами (отличными от наблюдаемого) подавляются в результате конкуренции.

Параметры установившихся макроскопич. структур не зависят (в нек-рых пределах) от изменения нач. условий. Они определяются лишь свойствами неравновесной диссипативной среды (поля). В этом смысле такие диссипативные структуры естественно назвать автоструктурами, подобно тому как установившиеся колебания в диссипативной системе с внеш. источником энергии называются автоколебаниями.

Др. пример С. — самопроизвольное образование спиральных волн в двумерном хим. реакторе, в к-ром протекает автокаталитич. реакция типа реакции Белоусова — Жаботинского (см., напр., [2]).

Теория С. представляет собой раздел нелинейной динамики неравновесных сред и основывается на сравнительно небольшом числе базовых моделей. Простейший (монотонный) процесс формообразования, установления статич. структур описывается т. н. градиентными моделями. Основная их особенность в том, что существует функционал, называемый функционалом свободной энергии, к-рый в процессе эволюции системы может только убывать, достигая при $t \rightarrow \infty$ минимума, соответствующего предельному статич. состоянию. В принципе, число таких минимумов, отвечающих структурам разл. типа, велико (мультистабильность); в неогранич. среде их может быть и бесконечное множество. В зависимости от нач. условий реализуется тот или иной статич. аттрактор системы. Так, напр., для ур-ния Сивфта — Хозберга

$$\partial u / \partial t = u + \beta u^2 - u^3 - (1 + \nabla^2)^2 u, \quad (1)$$

где параметр β характеризует величину квадратичной нелинейности (являющейся, в частности, моделью конвекции Рэлея — Бенара в горизонтальной ячейке больших размеров при небольших надкритичностях; в этом случае β определяет, напр., степень зависимости вязкости от тем-ры), имеется деск. аттракторов, среди к-рых большой областью притяжения обладает аттрактор, соответствующий правильной решётке с шестигранными ячейками (абс. минимум функционала свободной энергии). В процессе формирования этой решётки в зависимости от нач. условий наблюдаются «метаабильные» структуры (рис. 1).

Помимо подобных структур (типа решёток) для процессов С. характерно также образование локализованных структур (дефекты, дислокации, частицеподобные структуры), к-рые также могут быть описаны в рамках градиентных моделей [5]. Напр., в рамках модели, описываемой ур-нием типа ур-ния (1), но с жёстким возбуждением,

$$\partial u / \partial t = -u + \beta u^2 - u^3 - (1 + \nabla^2)^2 u, \quad (2)$$

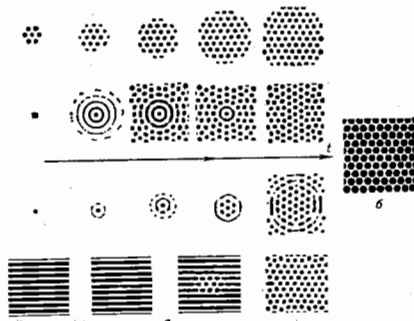


Рис. 1. Многообразие путей установления регулярной шестигранной решётки в модели (1): а — разные масштабы формирования устойчивой решётки; б — помехе значением свободной энергии.

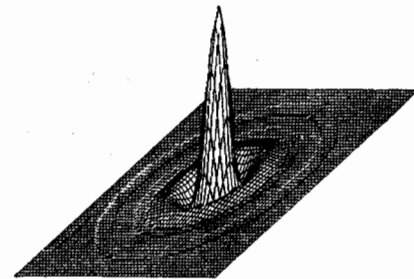


Рис. 2. Распределение поля для центрально-симметричной локализованной структуры, возникающей из начального беспорядка (в рамках модели (2)).

существуют частицеподобные локализованные состояния, такие, как на рис. 2.

Статич. структуры — это лишь одно из проявлений С. Во мн. эксперим. ситуациях наблюдается установление: вращающихся структур (напр., спиральные волны — рис. 3); решёток, периодических меняющих свою симметрию [4]; движущихся, сливающихся и вновь

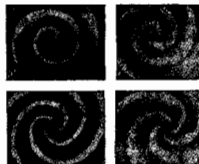


Рис. 3. Спиральные волны в двумерном химическом реакторе.

рождающихся локализованных структур (напр., дислокаций [5]). Подобным статич. структурам обычно отвечают аттракторы в виде иррегулярных циклов или маломерных торов. Среди осн. моделей, описывающих эти процессы, обобщённое ур-ние Гинзбурга — Ландау:

$$\partial u / \partial t = u[1 - (1 + i\beta)|u|^2] - (\kappa + i\delta)\nabla^2 u \quad (3)$$

(здесь ψ — комплексная физ. переменная, зависящая от пространственных координат и времени, а параметры системы вещественны и неотрицательны; β характеризует зависимость частоты осцилляций от их интенсивности, κ определяет величину диффузии, а δ — дисперсию пространственную). В рамках этого упрощения, в частности, описывать процесс саморазогрева упорядоченных структур в виде решёток, спиралей и т.п. представлял собой последовательное возникновение элементарных регулярных возмущений разл. масштабов, результат взаимодействия κ -рых между собой и есть суть процесса С.

Поскольку системы существенно диссипативны, а образам установившихся движений являются простые аттракторы, то действие шумов или внутр. флуктуаций неравновесной среды, как правило, качественно не влияет на процесс С. (конечно, если эти шумы и флуктуации достаточно малы).

Часто процессом С. противопоставляют процессу турбулизации неравновесной среды. В действительности между процессами развития регулярных структур и развития турбулентности (пространственно-временной беспорядка) имеется много общего. Прежде всего и для того и для др. процесса наиб. характерно вовлечение в процесс всё новых возмущений неравновесной среды. Только в первом случае (самоорганизации) эти возмущения синхронизированы друг с другом, а во втором — наоборот, взаимодействие этих элементарных возмущений рождает случайность (см. Странный аттрактор). Естественно, что в широкой области параметров неравновесной среды наблюдаются промежуточные состояния, κ -рые нельзя отнести ни к полной С., ни к развитой турбулентности. Такие состояния обычно называют пространственно-временным хаосом.

Лит.: 1) Пригожин И., Никольска Ж., Биологический порядок, структура и неустойчивость, «УФН», 1973, т. 109, в. 3, с. 517; 2) Жакоттис и де ла Туа А. М., Концентрационные колебания, М., 1974; 3) Зенкевич Г., Синхронизация. Критерии устойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах, пер. с англ., М., 1985; 4) Нелинейные волны. Динамика и эволюция. Сб. науч. трудов, под ред. А. В. Ганована-Грекова, М. И. Рабиновича, М., 1989; 5) Рабинович М. И., Стукан М. М., Регулярная и хаотическая динамика системы в течениях жидкости, «УФН», 1990, т. 160, с. 3.

В. С. Абраймович, М. И. Рабинович.

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — то же, что спонтанное излучение.

САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПОЛЕ в квантовой механике — эффективное (в простейших случаях среднее по времени) силовое поле, создаваемое частицами сложной системы (атома, ядра, твёрдого тела и др.). Служит для приближённого описания взаимодействия между частицами путём его замены воздействием С. п. на каждую из них; при этом решение многочастичной задачи сводится к рассмотрению движения отд. частицы в С. п. (и во внеш. поле, если оно имеется). Идея сходная с последним структурно, С. п. отличается тем, что зависит от состояния системы, определяемого самими же С. п. Это требует согласования вида С. п. с решениями динамич. ур-ний, зависящими в свою очередь от С. п., с чем и связан термин «самосогласованное».

С. п. описывает лишь часть взаимодействия между частицами, отвечающую воздействию ср. распределённых частиц системы на каждую из них. За рамками метода С. п. остаётся корреляционная (флуктуационная) часть взаимодействия, связанная с отличием мгновенного распределения частиц от среднего. Во мн. случаях корреляции играют незначит. роль и применение метода С. п. оправдано. Однако в ряде явлений (критич. явления, силы Ван-дер-Ваальса и др.) эта роль является определяющей.

Понятие С. п. в первонач. форме возникло в небесной механике, а затем вошло в теорию мн. частиц при описании ферромагнетизма [теория молекулярного поля, П. Вейс (P. Weiss, 1907)], пространственного заряда

[теория газового разряда, И. Ленгмюр (I. Langmuir, 1913)], тяжёлого атома Томаса — Ферми методом, Л. Томас (L. Thomas, 1927), Э. Ферми (E. Fermi, 1928)]. Строгое квантовомеханич. обоснование метода С. п. было дано Д. Хартри (D. Hartree, 1928) и В. А. Фоком (1930) вскоре после создания квантовой механики.

Для формулировки метода С. п. и понимания его смысла существенна особая роль взаимодействия в многочастичных системах. Порождая многообразие их свойств, взаимодействие сказывается и на способе теоретич. описания. В отсутствие взаимодействия, когда движение частиц динамически независимо, объектом описания может быть отд. частица системы (одн. ч. а. с. т. ч. и я. картина); состояние системы в целом полностью определяется состоянием каждой из её частиц. Взаимодействие разрушает эту картину, лишая смысла понятие о состоянии отд. частицы. Можно говорить лишь о состоянии системы как целого, κ -рал и становится теперь объектом описания. Это ведёт к качественному усложнению теории мн. частиц: вместо волновой ф-ции $\Psi_N(q)$ отд. частицы (q — совокупность пространственной, спиновой и др. координат, α — индекс состояния) вводят зависящую от N координат (N — число частиц в системе) волновую ф-цию всей системы $\Psi(q_1, q_2, \dots, q_N)$.

Идея метода С. п. состоит в том, чтобы сохранить одночастичную картину и при наличии взаимодействия, частично компенсируя возникающие при этом ошибки введением дополнит. (помимо внешнего) силового поля. Это поле, κ -рое и наз. С. п., подбирают так, чтобы свести указанные ошибки к минимуму. Поэтому метод С. п. — наилучший из всех возможных способов одночастичного описания системы взаимодействующих частей. При этом, простоте матем. аппарата (наиб. сложна процедура самосогласования) этот метод даёт эфф. описание взаимодействия между частицами, если эффекты коррел. взаимодействия невелики.

Основные уравнения. Одночастичному характеру метода С. п. отвечает мультичастичная структура волновой ф-ции системы:

$$\Psi(q_1, \dots, q_N) = \Psi_{\alpha_1}(q_1) \dots \Psi_{\alpha_N}(q_N). \quad (1)$$

Для тождественных бозе-(ферми-)частиц нужна симметризация (антисимметризация) ф-ции (1) по координатам, обозначаемая символом S :

$$\Psi(q_1, \dots, q_N) = S \Psi_{\alpha_1}(q_1) \dots \Psi_{\alpha_N}(q_N) \quad (2)$$

(в случае ферми-частиц это ведёт к детерминанту Сазтера — Фока). В частности, при $N = 2$:

$$\Psi(q_1, q_2) = \{\psi_{\alpha_1}(q_1)\psi_{\alpha_2}(q_2) \pm \psi_{\alpha_2}(q_1)\psi_{\alpha_1}(q_2)\} / \sqrt{2},$$

где здесь и ниже знаки «+» и «-» отвечают бозе-(ферми-) частицам. Различие правых частей (1) и (2) отвечает обм. и не (статистич.) корреляции (см. Обменное взаимодействие), присутствие тождеств. частицам. В отличие от силовых (динамич.) корреляций, порождаемых взаимодействием и отвечающих его корреляц. части, обменные корреляции описываются методом С. п.

Матрица плотности системы в методе С. п. также сводится к произведению одночастичных матриц плотности:

$$R(q, q') = \sum_{\alpha} n_{\alpha} \Psi_{\alpha}^*(q') \Psi_{\alpha}(q) = \langle \Psi^{\dagger}(q') \Psi(q) \rangle, \quad (3)$$

где n_{α} — числа заполнения уровней, $\Psi^{\dagger}(q)$ — операторная ф-ция уничтожения (рождения) в методе вторичного квантования, « Ψ » означает комплексное сопряжение, (...) — усреднение по состоянию системы. Так, парная матрица плотности имеет вид

$$R(q_1, q_2; q'_1, q'_2) = R(q_1, q'_1) R(q_2, q'_2) \pm R(q_1, q'_2) R(q_2, q'_1)$$

(в отсутствие обменных эффектов остаётся лишь первое слагаемое). Это выражение (я соответствующую функцию для ф-ции распределения) используют в приложении метода С. п. к термодинамике и кинетике.

Одностатистическую волновую ф-цию ψ_a выбирают в методе С. п. на условия макс. близости выражений (1), (2) к точной волновой ф-ции системы. С этой целью используют вариационный принцип, требующий минимума энергии системы $\mathcal{E} = \langle \Psi | H | \Psi \rangle$ при условии $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$, где

$$H = \sum_i T(q_i) + (1/2) \sum_{i,j} V(q_i, q_j), \quad (4)$$

H — гамильтониан системы, T — сумма кинетич. энергий и ввеш. поля, V — взаимодействие между частями, $i, j = 1, 2, \dots, N$. Волновая ф-ция (1) приводит к уравнению Хартри для ψ_a :

$$(T+W)\psi_a = \epsilon_a \psi_a, \quad (5)$$

включающему С. п.

$$W(q) = W_1(q) = \int dq' R(q, q') V(q, q') \psi_a(q').$$

Волновая ф-ция (2) приводит к уравнению Хартри — Фока, имеющему вид (5) с $W = W_1 \pm W_2$, где обменный член W_2 определяется соотношением

$$W_2(q) \psi_a(q) = \int dq' R(q, q') V(q, q') \psi_a(q') \psi_a(q').$$

Через одностатистич. энергию ϵ_a выражается полная энергия системы

$$\mathcal{E} = \sum_a \epsilon_a n_a - C, \quad C = (1/2) \int dq dq' V(q, q') [R(q, q) R(q', q') \pm \pm R(q, q') R(q', q)].$$

Согласно вариационному принципу эта величина всегда больше истинного значения энергии.

Величина W_1 имеет простой смысл ср. поля частиц системы, действующего на данную частицу, а W_2 ведёт к увеличению (уменьшению) вероятности сближения двух бозе-(ферми-)частиц, изменяя соотношения, образом их взаимодействия. Самосогласованному характеру величины W отвечает зависимость матрицы плотности (3) от решений уравнения (5), к-рое становится нелинейным и может поэтому иметь более одного набора решений. Так, при выполнении не-р-х условий возможно сосуществование двух решений уравнения (5), отвечающих однородному и неоднородному состояниям системы, каждое из к-рых устойчиво в своей области плотностей и темп-р. Это соответствует фазовому переходу со спонтанным нарушением трансляц. симметрии и с появлением *волн зарядовой плотности*.

В др. формулировке метода С. п. заменяют гамильтониан (4) выражением, к-рое соответствует одностатистич. картине. В методе вторичного квантования, где

$$H = \int dq \psi^{\dagger}(q) T \psi(q) + (1/2) \int dq dq' V(q, q') A(q, q'), \\ A(q, q') = \psi^{\dagger}(q) \psi^{\dagger}(q') \psi(q) \psi(q'),$$

эту картину нарушает входящий во взаимодействие оператор A , содержащий четыре операторы ф-ции вместо нужных двух. Модифициров. гамильтониан, отвечающий методу С. п., соответствует замене в A комбинаций $\psi^{\dagger} \psi$ их ср. значениями (матрицами плотности):

$$A \rightarrow 2[R(q', q') \psi^{\dagger}(q) \psi(q) \pm R(q, q') \psi^{\dagger}(q) \psi(q')] - \\ - [R(q, q) R(q', q') \pm R(q, q') R(q, q)], \quad (6)$$

и имеет вид

$$H_0 = \int dq \psi^{\dagger}(q) (T+W) \psi(q) - C.$$

Это выражение приводит к уравнению Хартри — Фока (5) и в то же время реализует минимум величины $\langle (H - H_0)^2 \rangle$, что и соответствует методу С. п. как наилучшему из одностатистич. способов описания.

Применения метода. Простейший объект приложения метода С. п. — бесконечная однородная система взаимодействующих по закону Кулона ферми-частиц с массой m , зарядом e и спином $1/2$ (электронов) в присутствии однородного компенсирующего фона противоположного знака заряда. В методе С. п. энергия такой системы в единице объёма равна $\hbar^2 \rho_0^2 / 10 \pi^2 m - e^2 \rho_0^2 / 4 \pi \epsilon_0$, где $\rho_0 = (3Z^2 n)^{1/3}$, n — плотность числа частиц, первый член — кинетическая, второй — обменная энергия. Этот результат используют для упрощения интегро-дифференц. уравнения Хартри — Фока (5), заменяя его Слаттера, где $W_2 = -e^2 [3Z^2 n(r)]^{1/3} / \pi$, $n(r) = \sum_a n_a |\psi_a|^2$ — локальное значение плотности числа частиц.

Др. упрощённым вариантом метода С. п. является метод Томаса — Ферми (квазиклассич. приближение к методу С. п.), применимый к слабо неоднородным системам, где ср. расстояние между частицами меньше характерной длины, на к-рой заметно меняется плотность и др. параметры системы. В методе Томаса — Ферми используют выражения, справедливые для однородной системы, относя их в каждой точке к соответств. локальному значению плотности. Этот метод используют для описания тяжёлых атомов, вещества в экстремальных условиях высоких давлений или темп-р и др. Применяют и иные, более частые способы упрощения метода С. п. (напр., в теории атома часто используют усреднение С. п. по углам, упрощающее отделение угл. переменных).

Метод С. п. находит применение в физике атома и молекулы, ядерной физике, физике конденсатов, состоянии вещества, физике плазмы и др. областях науки. Часто он даёт достаточно точное описание систем мн. частиц. Это относится, в частности, к атомно-молекулярной физике и теории спектроскопии, где метод С. п. применяют особенно широко благодаря относительно малому вкладу корреляц. эффектов. Напр., в атоме He (простейшей системе мн. частиц) этот вклад составляет $\sim 1.5\%$ от полной энергии электронной оболочки.

К числу др. важных применений метода С. п. в теории систем мн. частиц относятся описание равновесных и кинетич. свойств плазмы в бесстолкновн. режиме, *Ландау теория фазовых переходов 2-го рода* и др.

Обобщения метода. Существует ряд обобщений метода С. п., приспособленных для частичного описания корреляц. эффектов. Так, при необходимости учёта парных корреляций сверхпроводящего типа используют модифициров. гамильтониан (6), где заменяют ср. значения комбинаций $\psi^{\dagger} \psi$, $\psi^{\dagger} \psi^{\dagger}$, что приводит к уравнению Хартри — Фока — Боголюбова. Такой подход применяют в теории сверхпроводимости и в теории атомного ядра. Для описания многочастичных (дальних) корреляций, отвечающих поляризац. эффектам в кулоновской системе, используют зависящие от времени уравнения Хартри — Фока:

$$i \hbar \partial R(q, q', t) / \partial t = (T_q + W_q - T_{q'} - W_{q'}) R(q, q', t)$$

(индекс указывает переменную, на к-рую действует оператор). Это уравнение определяет нестационарную одностатистич. матрицу плотности и оказывается равновесным приближением случайных фаз (приближению высокой плотности), совпадая в то же время с кинетич. уравнением, включающим С. п. без учёта столкновений. Его применяют для описания коллективных возбуждённых состояний системы.

При необходимости систематич. описания корреляц. эффектов метод С. п. служит хорошим исходным приближением для последующего применения теории возмущения и диаграммной техники. Корреляц. части взаимод. действия отвечает гамма-волны $H' = H - H_0$. Выбор при описании системы взаимодействующих частиц картины С. п. (а не картины не взаимодействующих частиц) в качестве исходного приближения упрощает матем. аппарат описания корреляц. эффектов, в частности сокращается число диаграмм теории возмущений.

В последние годы в теории мн. частиц получил широкое распространение полуженерологич. метод функций и вала плотно сти, обобщающий подход, основанный на ур-ниях Хартри—Фока—Ситтера и предельных значениях для описания не только обменных, но и силонных корреляций. В этом методе используются ур-ния Кона—Шема, имеющие вид ур-ний (5) с $W = W_1 \pm W_0$, где член W_0 , описывающий корреляции обоих типов, выбирает в виде относительно простого функционала плотности. Имея ограниченную и не всегда ясную область применимости, метод функционала плотности тем не менее успешно используется в физике атома, атомного ядра и в физике конденсиров. сред (в частности, для расч. зонной структуры твердых тел, для описания поверхностных явлений). Лит.: Фо и В. А., Многоэлектронная задача квантовой механики и строение атома, в кн.: Юбилейный сборник АН СССР, ч. 1, М.—Л., 1947, с. 255; Хартри Д. Р., Расчеты атомных структур, пер. с англ., М., 1960; Гаульс Д., Квантовая механика систем многих частиц, пер. с англ., 2 изд., М., 1975; Ниржини Д. А., Полевые методы теории многих частиц, М., 1983; Слиттер Дж., Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел, пер. с англ., М., 1978; Теория неоднородного электронного газа, пер. с англ., М., 1987.

САМОСЯТЯЖИВУЮЩИЙ ОПЕРАТОР — см. Эрмитов оператор.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД — влечрич. ток в газе, не требующий для своего поддержания действия веш. ионизатора. С. р. образуется при достаточно высоком напряжении на электродах, когда начавшийся разряд создаст необходимые для его поддержания ионы и электроны (см. Электрические разряды в газах).

САМОСТЯЖИВАЮЩИЙСЯ РАЗРЯД — то же, что контрагированный разряд.

САМОФОКУСИРОВКА в ускорителях χ — свойство релятивистских электронных пучков, содержащих подложит. ионы, образовывать равновесные (самофокусирующиеся) конфигурации. Оно обусловлено ослаблением кулоновского растаивания в электронном пучке (за счет сил маг. сжатия, вызванных параллельным движением зарядов в пучках) в χ^2 раз, где $\chi = \beta/\beta_0$ — отношение энергии электронов пучка к их энергии покоя ($\beta_0 = mc^2$, m — масса электрона). Если $\chi \gg 1$, то это растаивание может быть полностью скомпенсировано добавлением небольшого числа положительных ионов:

$$N_+ = N_- \chi^2 Z, \quad (*)$$

где N_- и N_+ — соответственно плотности числа электронов и ионов, Z — заряд иона (в единицах величин заряда электрона). Ионы, в свою очередь, удерживаются кулоновским полем электронов. Условие (*) впервые сформулировано У. Х. Беннетом (W. H. Bennett) в 1934.

Лит.: Беннетт У. Х., Magnetically self-focusing streams, Phys. Rev., 1934, т. 45, p. 890.

САМОФОКУСИРОВКА СВЕТА — концентриция энергии световой волны, распространяющейся в нелинейной среде, показатель преломления n к-рой растет с увеличением амплитуды поля E :

$$n = n_0 + n_{nl}(|E|^2). \quad (1)$$

Показатель преломления среды может увеличиваться с ростом поля E вследствие изменения нелинейной поляризации среды, оптич. Керра эффекта, электрострикциии, нагрева, резонансного возбуждения среды и т. д.

Под действием светового пучка, имеющего, напр., гауссову форму, нелинейная среда становится оптичски неоднородной: в центре пучка, где больше интенсивность, показатель преломления больше, чем для краев пучка, а следовательно, фазовая скорость в центре будет меньше, чем по краям пучка. Это приведет к искривлению первоначально плоского волнового фронта, а лучи, распространяющиеся по нормали к фронту, искривляются (нелинейная рефракция) к оси (рис. 1, а). Первоначально однородная среда становится своеобразной

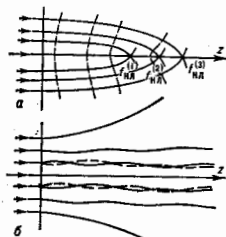


Рис. 1. Самофокусировка света в нелинейной среде: а — возникновение коллизы и многофокусировки (штриховыми линиями показана волновая фронт); б — траектория лучей в возникающем нелинейном диэлектрич. волноводе.

объемной собирающей линзой, фокус к-рой находится на нек-ром расстоянии f_{nl} от входа пучка в среду. Явление С. с. теоретически было предсказано Г. А. Аскарьяном в 1962 и впервые наблюдалось Н. П. Пилинечем и А. Р. Рустамовым в 1965.

В тонком нелинейном слое, толщина к-рого l значительно меньше фокусного расстояния f_{nl} , всё происходит по многому аналогу самофокусировке света, только в случае фокусировки $f_{nl} > 0$ и лучи, пройдя слой, сначала сходятся в фокальной плоскости, а затем уходят в дальнее поле. Как и при самофокусировке, благодаря нелинейным aberrациям, угл. распределение пучка при прохождении им самофокусирующей линзы имеет кольцевую структуру.

Если толщина нелинейного слоя $l \gg f_{nl}$, С. с. описывается квазиоптич. нелинейным ур-нием, в к-ром учитываются не только нелинейная рефракция, но и дифракция:

$$\partial A / \partial z = (2ik)^{-1} \Delta_1 A + k_0 n_{nl}(|A|^2) A. \quad (2)$$

Это парабол. ур-ние типа нелинейного ур-ния Шрёдингера имеет ряд интегралов движения I_i , сохраняющих свои величины в процессе распространения, $\partial I_i / \partial z = 0$. Кроме очевидного интеграла $I_1 = \iint |A|^2 dx dy = \text{const}$, выражающего закон сохранения энергии, существует интеграл

$$I_2 = \iint (|\nabla_1 A|^2 - k_0 n_{nl}(|A|^2)) dx dy, \\ I_{nl} = \int_0^l |A|^4 n_{nl}(\xi) d\xi, \quad (3)$$

характеризующий соотношение линейной дифракции (первый член подынтегрального выражения) и самодействие пучка. В слабых полях ($A \rightarrow 0$, $n_{nl} \rightarrow 0$, $f_{nl} \rightarrow \infty$) интеграл (3) положительн и пучок испытывает только дифракцию. Однако в нелинейной среде под воздействием достаточно сильных полей знак I_2 может стать отрицательным за счет члена f_{nl} и линейная дифракция сменяется самофокусировкой или образованием нелинейного волновода (рис. 1, б). Нелинейный волновод образуется при компенсации дифракц. расходимости нелинейной рефракцией:

$$\theta_{\text{диф}}^0 \approx \Delta n_{nl} / n_0; \quad \theta_{\text{диф}} = 2/ka.$$

Поперечное распределение амплитуды в нелинейном волноводе можно рассчитать, если искать решение

ур-ния (2) в виде неограниченного пучка ($A \rightarrow 0$ при $|z|, |y| \rightarrow \infty$).

$$A = E_B(x, y) \exp(-iq_B z), \quad (4)$$

где E_B и q_B — собств. ф-ции и собств. числа пространственных мод нелинейного волновода. В кубичной нелинейной среде, когда $n_{\text{нл}} = n_2 |E|^2$, амплитудный профиль E_B описывается ур-нием, следующим из (2):

$$\Delta_1 E_B + 2kq_B E_B + 2kk_0 n_2 E_B^3 = 0. \quad (5)$$

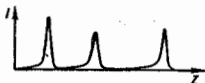
При распространении пучка в среде существует дискретный спектр нелинейных мод, каждая из к-рых несёт свою критич. мощность, начиная с к-рой пучок самофокусируется. Так, напр., низшая осесимметричная мода, имеющая колоколообразный амплитудный профиль, имеет критич. мощность

$$P_{\text{нр}} = 1,86 k_0^3 / 32 \pi^2 n_2, \quad (6)$$

к-рая не зависит от поперечного радиуса пучка a , прямо пропорциональна квадрату длины волны (чем меньше λ_0 , тем слабее дифракционная расходимость, тем при меньшей мощности начинается эффект самофокусировки) и обратно пропорциональна коэф. нелинейности n_2 .

С увеличением амплитуды поля E_0 нелинейный фокус смещается ко входу и вслед за первым фокусом возникает второй, третий и т. д. (рис. 1, а и рис. 2). Число фокусов растёт с увеличением мощности источника,

Рис. 2. Многофокусная самофокусировка пучка в среде с кубичной нелинейностью.



возникает многофокусная структура. В случае мощных коротких импульсов фокусы движутся очень быстро, с околосветовой скоростью.

В мощных пучках с $P_0 \gg P_{\text{нр}}$ нелинейная рефракция превалирует над дифракцией и для описания поведения пучка можно воспользоваться методом геом. оптики, представляя в (2) $A = (A_0 + k^{-1} A_1 + \dots) \exp(-ikz)$ при $k \rightarrow \infty$ ($\lambda \rightarrow 0$). Тогда можно получить след. ур-ния:

$$\frac{d^2 a}{dz^2} + \frac{1}{2} (\nabla_1^2)^2 a = n_2 A_0^2; \quad \frac{\partial A_1^2}{\partial z} + \nabla_1^2 (A_0^2 \nabla_1^2) = 0, \quad (7)$$

первое из к-рых — ур-ние *зайкама* в нелинейной среде, второе — ур-ние переноса излучения. Величина $\nabla_1^2 = 0$ имеет простой смысл угла наклона элементарного луча к продольной оси z . Из (7) легко найти ур-ния для θ и A_0 , аналогичные ур-ния гидродинамики. Ур-ния (7) имеют простое автомодельное решение для параболич. профиля пучка:

$$A_0 = E_0 a_0 |1 - r^2/a^2(z)|/a(z), \quad s = \varphi(z) + r^2(da/dz)/2a(z), \quad (8)$$

где поперечный радиус пучка уменьшается с расстоянием по закону

$$a(z) = a(0) (1 - z^2/f_{\text{нл}}^2)^{1/2}. \quad (9)$$

Видно, что траектории всех лучей подобны друг другу, они сходятся в одну точку, расположенную на расстоянии $z = f_{\text{нл}}$

$$f_{\text{нл}} = a(0) (n_0/n_2 E_0^2)^{1/2}. \quad (10)$$

По мере приближения к фокусу луч всё более искривляется, а поле на оси неограниченно нарастает $A(0, z) \approx$

$\approx P_0/a^2(z)$. Пучок схлопывается (*волновой коллапс*). Это явление не устраняется даже с учётом дифракции и нелинейных aberrаций.

Картина в ста-ции она рной самофокусировки с учётом релаксации нелинейности описывается ур-нием

$$\nabla_{\text{р}} \frac{\partial n_{\text{нл}}}{\partial t} + n_{\text{нл}} = n_2 |A|^2. \quad (11)$$

Т. к. передняя часть импульса света не участвует в С. с., она распространяется как в линейной среде, испытывая только дифракцию, а средняя и задняя части импульса, испытывая ещё и нелинейную рефракцию, самофокусируются, образуя квазиволновод (рис. 3). Поле в квазиволноводе нарастает медленнее и ограничено

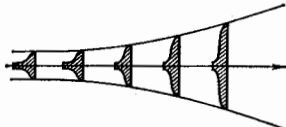


Рис. 3. Картина нестационарной самофокусировки короткого светового импульса. На переднем фронте нелинейный отклик ещё не установился и происходит линейное распространение импульса, задняя часть импульса сжимается за счёт нелинейной рефракции.

по величине (нет коллапса). На больших расстояниях из-за дифракционного распыливания передней части импульса длина квазиволновода сокращается вплоть до полного исчезновения.

Мощный световой пучок испытывает в самофокусирующей среде модулят. неустойчивость, приводящую к т. н. мелкомасштабной С. с. Если в световой волне с амплитудой E_0 появляются пространственные флуктуации ρ (малые возмущения амплитуды и фазы)

$$E = E_0 \exp(-ik_0 n_2 E_0^2 z) + \rho, \quad (12)$$

то благодаря параметрич. неустойчивости амплитуда малых возмущений экспоненциально растёт с расстоянием $\rho \propto \exp \Gamma z$. Отд. пространственные фурье-компоненты $\rho = \rho_0 \cos(x/a) \cos(y/a)$ имеют разные инкременты $\Gamma = (1/ka)^{-1} [-1 + n_2 E_0^2 k^2 a^2 / n_0]^{1/2}$. Наиб. инкремент

$\Gamma_{\text{макс}} = k_0 n_2 E_0^2 a_0$ имеют возмущения с поперечным масштабом модуляции $a_{\text{опт}} = (\lambda/2\pi)(n_0/n_2 E_0^2)^{1/2}$, поэтому пучок разбивается на отд. нити с радиусом $a_{\text{опт}}$. В нити с таким радиусом захватывается мощность порядка критической. В пучке происходит конкуренция самофокусировки пучка как целого на длине $f_{\text{нл}} = (1/2) a_0 (n_0/n_2 E_0^2)^{1/2}$ и процесса распада пучка на отд. нити за счёт дифракции. Если профиль пучка достаточно гладкий, то мелкомасштабная структура не проявляется на длине, равной $f_{\text{нл}}$.

Самофокусировка может развиваться и на квадратичной нелинейности при трёхволновом когерентном взаимодействии, когда частоты и волновые векторы связаны соотношениями $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$ и $k_1 + k_2 = k_3$. В вынужденном по частоте случае генерация второй отгук. гармоники с учётом дифракции описывается двумя амплитудными ур-ниями:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} &= \frac{i}{2k_1} \Delta_1 A_1 - i\gamma_2 A_2 A_3^* ; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} &= \frac{i}{2k_2} \Delta_1 A_2 - i\gamma_2 A_1^2, \end{aligned} \quad (13)$$

где $\gamma_2 = 2\chi_{22} \omega_1 / c n$ — коэф. нелинейности, χ_2 — нелинейная восприимчивость 2-го порядка.

При возбуждении гармоник независимо от знака коэф. нелинейности χ_2 С. с. возникает одновременно у двух пучков (рис. 4). Критич. мощность двухволновой взаимоконфокусиры $P_{кр} = c\lambda^2/d\chi_2^2$.

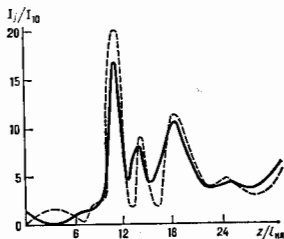


Рис. 4. Взаимоконфокусира волновых пучков основной (сплошная линия) и второй (штриховая линия) гармоник в среде с квадратичной нелинейностью.

С. с. может привести к световому пробою, способствует развитию процессов вынужденного рассеяния и др. нелинейных процессов. С помощью С. с. можно создавать сверхдлинные световые поля.

Лит.: Ахманов С. А., Сухоруков А. П., Хохлов Р. В. Самофокусировка и дифракция света в нелинейной среде. «УФН», 1967, т. 89, с. 19; Аскарян Г. А. Эффект самофокусировки. «УФН», 1973, т. 111, в. 2, с. 249; Луговой В. Н., Прохоров А. М. Теория распространения мощного лазерного излучения в нелинейной среде, там же, с. 203; Сухоруков А. П. Нелинейные волновые взаимодействия в оптике и радиотехнике. М., 1988; Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики, пер. с англ., М., 1989.

САНИ... (от лат. *centum* — сто) — приставка к наименованию единицы физ. величины при образовании дольной единицы, равной $1/100$ от исходной. Сокращённое обозначение — с. Пример: 4 см — 0,01 м.

САНИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ (СМВ) — радиоволны в диапазоне длин волн 4–10 см (частоты 3–30 ГГц). Влияние *ионосферы* на распространение СМВ невелико — поглощение практически отсутствует, а фазовый сдвиг, пропуск. длине волны, составляет для стандартной дневной *ионосферы* при вертикальном распространении волн 3–30 рад. В нейтральной атмосфере имеют место молекулярное поглощение СМВ водяным паром (слабая линия вращат. спектра водяного пара с резонансом на длине волны $\lambda = 1,35$ см) и, при наличии облаков и осадков, поглощение в жидкокапельной фракции. Именно мощные облака и дожди приводят к наиб. существенному поглощению СМВ, к-рое достигает в зенитном направлении единиц и даже десятков дБ в КВ части диапазона СМВ. Коэф. поглощения в преломлении в облаках определяются комплексной диэлектрич. проницаемостью воды $\epsilon_{\text{в,с}}$, к-рая в диапазоне СМВ имеет резкую частотную зависимость, а также зависит от темп-ры воды и степени её минерализации. Водная среда для СМВ является сильно поглощающей (толщина скин-слоя < 1 см), обладающей большим коэф. преломления n , следовательно, сильно отражающей и рассеивающей. В безоблачной атмосфере поглощение СМВ определяет водяной пар.

Преломление СМВ в атмосфере из-за влияния водяного пара превосходит преломление эл.-маг. волн в оптич. диапазоне и, возраста с ростом зенитного угла, достигает значений 30–40°. Загроизанное распространение СМВ незначительно и связано гл. обр. с волноядом распространением, к-рое возникает в случаях, когда в приземном слое атмосферы градиент коэф. преломления $dn/dh < -1,57 \cdot 10^{-4} \text{ км}^{-1}$. Флуктуация интенсивности СМВ вследствие турбулентности атмосферы при величине структурной постоянной $C_n^2 = 10^{-14}$

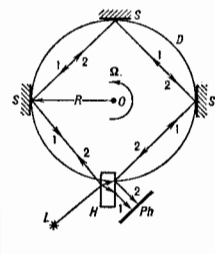
см⁻² обычно не превышает 5–10%; угл. поперечный радиус корреляции порядка размера Френеля зоны — $\sqrt{\lambda L}$ (L — длина трассы). Среди эффектов, возникающих при распространении СМВ в атмосфере, следует отметить рассеяние на гидрометеорох (облака, дожди, снег), к-рое имеет рэлеевский характер, а на длинах волн $\lambda < 3$ см — деполяризацию, возникающую из-за отклонения формы частиц гидрометеорох от сферической.

В качестве источников СМВ используются ламповые и транзисторные генераторы, генераторы на туннельных и лавинно-пролётных диодах, диодах Ганна, искровой разряд, клистроны, лампы обратной (ЛОБ) и бегущей (ЛБВ) волн, магнетроны, мазеры на циклотронном резонансе (МЦР). Естествен. источниками СМВ являются галактич. и внегалактич. источники, имеющие, как правило, ступенчатый спектр (радиогалактики, квазары, остатки вспышек сверхновых, центр Галактики, туманности, космич. мазеры на H_2O), а также Луна, планеты (яркостая темп-ра к-рых $\sim 100 \sim 500$ К), атмосфера Земли и земные покровы, спорадич. всплески в околоземном пространстве, Солнце [яркостая темп-ра к-рого в диапазоне $1,3 \leq \lambda \leq 100$ см составляет $T = 4,5 \cdot 10^6$ К (спокойное Солнце)], а в периоды высокой активности увеличивается в 2–3 раза]. Специфика диапазона СМВ — прозрачность *ионосферы*, возможность реализации узкой диаграммы направленности при сравнительно небольших размерах антенн, возможность генерации коротких импульсов, а также низкий уровень помех — привела к широкому использованию СМВ в радиолокации, радиоастрономии, связи на трассах Земля — космич. аппарат. Зависимость коэф. поглощения и отражения, а следовательно, и теплового излучения СМВ от диэлектрич. параметров, на к-рые сильно влияет наличие влаги, а также тот факт, что излучение проникает или формируется в слое, толщина к-рого пропорц. длине волны, позволяют использовать СМВ для дистанционного зондирования радиолокац. и радиотермич. (по собств. излучению) методами. Так, с ИСЗ определяются увлажнённости полей и уровень грунтовых вод, толщина и водозап. снежного покрова, оцениваются характеристики растительного покрова и прогнозируются урожайности. Определяются также глобальное распределение атмосферного водяного пара, поле темп-ры и степень взволнованности морской поверхности, скорость ветра, концентрация, тип и возраст морского льда, его толщина. Измерения рефракции СМВ при радиопросвечивании атмосферы планеты с космич. аппаратов используются для восстановления высотных профилей темп-ры, давления и содержания газовых компонентов. СМВ находят применение для определения подповерхностного профиля темп-ры и глубины промерзания грунта, определения глубины темп-ры внутр. тканей тела по измерениям теплового излучения. СМВ применяются для внутр. нагрева, в частности в медицине для неинвазивного лечения опухолей (гипертермия).

Лит.: Альперт Я. Л., Гинзбург В. Л., Фейнберг Е. Л. Распространение радиоволн. М., 1953; Татарский В. И. Распространение волн в турбулентной атмосфере. М., 1967; Фок В. А. Проблема дифракции и распространения электромагнитных волн. М., 1970; Введенский В. А. Распространение ультранизких радиоволн. М., 1973; Колосов М. А., Шабаев С. и Иванов В. А. Рефракция электромагнитных волн в атмосфере Земли. Венер и Марс. М., 1976; Губанов В. С., Физкальштейн А. М., Фришман П. А. Введение в радиостроение. М., 1983; Шутко А. М. СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов.

САВЬЯКА ОПЫТ, доказал возможность эксперим. определения угл. скорости вращения системы для расположенного в ней наблюдателя, т. е. возможность определения внерелятивистской системы для находящегося в ней наблюдателя (эффект Савьяка). Проведён Ж. Савьяком (G. Sagnac) в 1913. В С. о. (рис.) на круглом диске D располагались зеркала S , источник света I и фототр. пластинка Ph . Полуцирочащая пластинка H делила луч света от источника на два: луч 417

1 шёл по замкнутому пути в направлении вращения диска, луч 2 — в противоположном направлении. При вращении всей системы с угл. скоростью Ω вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска, луч 1, согласно общей теории относительности, с точки зрения наблюдателя, находящегося на диске, тратит на полный обход больше времени, чем луч 2; разность времён обхода $\Delta t = 4\pi R^2 \Omega / c^2$, где R — радиус окружности, на к-рой располагаются зеркала S и пластинка H . В результате на фотопластинке при вращении диска наблюдается смещение интерференц. полос (по сравнению с их положением при покоем диске) на величину $\Delta Z = \Delta \varphi / 2\lambda = c \Delta t / \lambda = 4\pi R^2 \Omega / c \lambda$, вы-



раженную в λ , где λ — длина волны излучения монохроматич. источника света L частоты $\omega = 2\pi c / \lambda$, а $\Delta \varphi$ — разность фаз встречных волн 1 и 2. При $R \approx 100$ см, $\lambda \approx 10^{-4}$ см и $\Omega \approx 10^4$ с $^{-1}$ (угл. скорость вращения Земли) сдвиг интерференц. полос составляет малую долю: $\Delta Z \approx 4 \cdot 10^{-4}$. Это же выражение для разности фаз $\Delta \varphi = \omega \Delta t = 8\pi^2 R^2 \Omega / c \lambda$ можно получить для наблюдателя, покоящегося в лаб. системе отсчёта. Действительно, если рассматривать нерелятивистское вращение точек диска, когда $R\Omega \ll c$, время Δt_1 распространения луча 1 по направлению вращения определяется из соотношения (рис. 2) $2\pi R + R\Omega \Delta t_1 = c \Delta t_1$. Здесь $R\Omega \Delta t_1$ — доплит. расстояние, на к-рое сдвинется пластинка H (уйдёт от догоняющего её луча 1) за время Δt_1 обхода луча по замкнутому контуру. Аналогичное соотношение для луча 2: $2\pi R - R\Omega \Delta t_2 = c \Delta t_2$. В результате при $R\Omega \ll c$ $\Delta t = \Delta t_1 - \Delta t_2 = 4\pi R^2 \Omega / c^2$. Иногда эту разность времён, возникающую в лаб. системе отсчёта, связывают с разностью доплеровских частот, искусственно движущейся пластинкой по направлению лучей 1 и 2.

Основываясь на результатах С. о., А. Майкельсон (А. Michelson) и Г. Гейл (H. Gwile) в 1925 определили скорость вращения Земли вокруг своей оси. В 1982 этот опыт был повторён А. Джаваном (А. Javan) с использованием когерентного излучения гелий-неонового лазера. Основные на эффекте Саявья интерферометры с лазерными источниками света используются в качестве датчиков угл. скорости, угла поворота и ориентации в пространстве для вращающихся объектов. Чувствительность таких интерферометров можно заметно увеличить, если использовать многократные (N -кратные) обходы по замкнутому контуру встречных лучей 1 и 2. Тогда $\Delta Z_N = N \Delta Z$, где $\Delta Z = 4\pi R^2 \Omega / c \lambda$. Такая схема реализуется в совр. волоконно-оптич. интерферометрах (см. *Волоконно-оптический гироскоп*). В них излучение, распространяющееся внутри оптч. волокон, намотанных, как в солеедах, на цилиндрич. стержень, N -кратно проходит по замкнутому контуру (где N — число витков намотки витков). Для такого интерферометра при $R \approx 20$ см, $\lambda \approx 10^{-4}$ см и $N \approx 5 \cdot 10^6$ при оптч. волокне с поперечным сечением в 100 мкм 2 $\Delta Z \approx 8 \cdot 10^{-4}$, а $\Delta Z_N \approx 4\%$, что можно наблюдать даже невооружённым глазом.

Лит.: Л я и л а у Л. Д., Л и ф и н Д. Е. М., Теория поля. 7 изд., М., 1988; Ф р а н к Ф у р т У. И., Специальная и общая теория относительности. Исторические очерки, М., 1968.

С. Н. Столяров.

САСАКИ — ШИБУЙА ЭФФЕКТ — анизотропия электропроводности полупроводниковых кристаллов кубич. симметрии в сильных (горячих) электрич. полях (см. *Горячие электроны*). Предсказан М. Шибуйа в 1953, обнаружен в кристаллах n -Ge в 1956 В. Сасаки и Шибуйа. Различают продольный и поперечный

С. — Ш. э. Продольный С. — Ш. э. состоит в различии вольт-амперных характеристик (ВАХ) однородно-длинных кристаллич. образцов при разных направлениях тока (обычно такие образцы вырезают вдоль

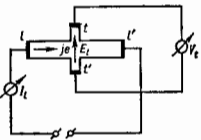


Рис. 1. Схема установки для измерения эффекта Сасаки — Шибуйа; I, I' — токовые контакты; i, i' — электроды для измерения эдс Сасаки (поля E_i).

кристаллографич. осей [100], [111], [110]). В слабых полях все ВАХ имеют одинаковый наклон. В сильных полях наклон различен; с понижением темп-ры это различие, как правило, усиливается, и иногда для нек-рых направлений возникает участка *отрицательным дифференциальным сопротивлением*.

Поперечный С. — Ш. э. состоит в возникновении в сильных полях в образцах, вырезанных вдоль произвольных направлений, отличных от осей симметрии, поперечной эдс (а д с С а к и). Она фиксирует появление угла между направлениями электрич. тока I и напряженности электрич. поля E (угл. Сасаки). Эдс Сасаки измеряется так же, как эдс Холла (см. *Холла эффект*), но в отсутствие магн. поля (рис. 1). Наряду с измерениями в пост. электрич. полях (импульсных — во избежание разогрева джоулевым теплом) для исследования анизотропии проводимости горячих электронов использованы СВЧ-поля.

С. — Ш. э. объясняется анизотропией закона дисперсии горячих носителей заряда $\mathcal{E}(p)$, где \mathcal{E} — энергия носителя заряда, p — их квазиимпульс. Наб. эффект не выражен в *многообразных полупроводниках* благодаря междолинному перераспределению носителей заряда, вызываемому их разл. нагревом в разных долинах. В многодолинных полупроводниках минимум энергии в зоне проводимости (или максимум в валентной зоне) достигается не при $p = 0$, а сразу в нек-р. эквивалентных точках приведенной *Бриллюэна зоны*, напр. в 4 точках L на её поверхности в n -Ge и халькогенидах Pb (PbS, PbSe, PbTe); в 6 точках (на Δ -оси) в n -Si и алмазе. Большая величина С. — Ш. э. связана с сильной анизотропией спектра электронов $\mathcal{E}(p)$ в каждой из долин, где изоэнергетич. поверхность электрона $\mathcal{E}(p) = \text{const}$ имеет форму сфероида (эллипсоида вращения) с большой осью, массой m_l вдоль оси вращения и с малой m_t поперёк её. Если электрич. поле направлено так, что образует разл. углы φ с осями вращения эллипсоида в разл. долинах ($0 < \varphi < \pi/2$), то электроны в долинах разогреваются по-разному, причём сильнее всего в тех долинах, в к-рых углы φ оказываются наибольшими (рис. 2).

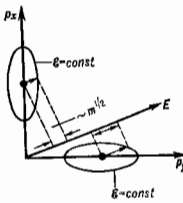


Рис. 2. Двухдолинная модель с различными эффективными массами m для разного направления поля E .

Разл. нагрев электронного газа приводит, во-первых, к разл. скорости рассеяния электронов в разл. долинах, определяющей при низких темп-рах подвижности носителей заряда; во-вторых, к разл. скорости перехода электронов из горячих долин в холодные, что определяет зависимость доли электронов, связанная с энергетич. зависимость вероятностей рассеяния носителей заряда (внутри- и междолинного). В чистых и структурно совершенных кристаллах преобладает междолинное рассеяние с испусканием и погло-

щением коротковолновых фонов. Вероятность такого рассеяния растёт с ростом энергии электрона ϵ , так что более разогретые долины успокоаются, а менее разогретые избыточно заполняются электронами. В результате, напр., в n -Ge в одинаковом электрич. поле токи $i < i_{100} < i_{111}$ в n -Si токи $i_{100} < i_{111} < i_{111}$ (в орм а л я в в С. — Ш. з.).

В легированных полупроводниках при низких темп-рах доминирует междолинное рассеяние на примесных центрах и дефектах. Вероятность рассеяния в этом случае может спадать с ростом энергии электронов, так что сильное разогретые долины избыточно наполняются, а менее разогретые — успокоаются. К тому же внутридолинное рассеяние на заряд. примесях способствует росту подвижности с разогревом. Это сочетание приводит к т. н. аномальному у С. — Ш. з., при к-ром неравенства изменяют знак, т. е. n -Ge ведёт себя, как n -Si (и наоборот).

Анизотропия закона дисперсии возникает в p -Ge и n -Si из-за гофрировки изоэнергетич. поверхностей валентных зон (в особенности зоны тяжёлых дырок), связанной с их вырождением в точке зонной диаграммы ϵ (р) $p = 0$ (см. Зонная теория).

При переходе от нормального С. — Ш. з. к аномальному изменяется также знак поперечной эдс Сасаки. На рис. 3 представлена зависимость поперечного поля

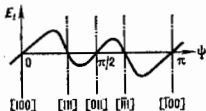


Рис. 3. Поперечная эдс Сасаки в зависимости от угла ϕ между полем E в плоскости (011) и кристаллографической осью [100].

E_1 (при заданном продольном поле E) от угла ϕ между направлением тока j , лежащего в плоскости симметрии (011), и осью симметрии [100]. При токе, направленном вдоль осей [100], [111], [011], поперечное поле E_1 отсутствует. Знак E_1 различен у Ge и Si при нормальном С. — Ш. з. и изменяется с переходом к аномальному эффекту.

В чистых полупроводниках при достаточно низких темп-рах (в n -Si при $T = 55$ К) в определ. диапазоне E поперечное поле E_1 в плоскости (011) неустойчиво. В частности, в n -Si при j вдоль оси [011] неустойчиво значение $E_1 = 0$ при $\phi = \pi/2$, а устойчивыми оказываются два ненулевых, равных по величине и противоположно направленных поля, параллельных осям [011] и [011]. Этим двум значениям E_1 соответствуют преимущественные заполнения электронами долин с осями вращения эллипсоидов вдоль осей [010] или [001]. В результате в одном образце могут сосуществовать области (домены) с разл. устойчивыми значениями E_1 , разделённые доменными стенками. При токе вдоль оси [011] домены имеют вид слоев, параллельных плоскости (011), с чередующимися по знаку полями E_1 . Для тока вдоль осей [111] есть 3 равных E_1 , направленных под углами 120° друг к другу (в многогранной эдс эффект Сасаки).

Кроме разогретого механизма С. — Ш. з. возможен стрикционный механизм: электрич. поле вызывает анизотропную деформацию кристалла, к-рая по-разному изменяет энергетич. положение долин. Этот механизм доминирует в многодолинных полупроводниках с высокой диэлектрич. проницаемостью (напр., в BaTiO_3).

Лит.: З е р г е р К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Горячие электроны в многодолинных полупроводниках, К., 1982.

З. С. Гриншпик.

САТУРН — шестая по удалению от Солнца и вторая по размерам и массе планета Солнечной системы. Ср. геоцентрич. расстояние (большая полуось орбиты) составляет 9,539 а. е. (1,427 млрд. км). Вследствие заметного эксцентриситета орбиты (0,056) гелиоцентрич. расстояние изменяется прибл. от 9 до 10,1 а. е. Наклон

плоскости орбиты к эклиптике $2'29,4'$, ср. скорость движения по орбите 9,64 км/с, а период обращения вокруг Солнца (сидерич. период, или сатурнианский год) 29,458 земных года. Мин. расстояние между С. и Землей составляет 1,2 млрд. км, максимальное — 1,6 млрд. км; соответственно видимые угл. размеры диска изменяются от $20'$ до $15'$. Синодич. период обращения равен 378,09 сут. Видимая азимутная величина С. в ср. противостоянии 0,67, абс. планетная величина 8,88. Интергальное сферич. альбеда 0,34 г.

Ср. экваториальный радиус С. (по уровню в атмосфере с давлением 1 бар) $R_0 = 60246 \pm 10$ км, масса (M_0) $5,68 \cdot 10^{28}$ кг. Из-за быстрого вращения вокруг оси (период на экваторе $\approx 10,2$ ч) С. обладает большим сжатием ($-0,1$), вследствие чего его полярный радиус почти на 500 км меньше экваториального. Существенно при этом, что период вращения меняется с широтой (скорость вращения экваториальной зоны прибл. на 5% выше полярной). Ср. плотность С. — самая низкая из всех планет, всего $0,69$ г/см³, что прибл. вдвое меньше плотности Солнца. Ускорение силы тяжести на экваторе $10,45$ м/с², параболич. скорость (скорость убегания) ок. 36 км/с.

Твёрдой поверхности С. не имеет и является газоидным телом, находящимся в состоянии гидростатич. равновесия. Структура его недр в целом подобна структуре Юпитера. Согласно моделям внутр. строения планет (см. Планеты и спутники), основанным на представлениях об адиабатич. изменении темп-ры по глубине в многослойной дифференциации вещества невр. внутр. газовой оболочка С. является водородно-гелиевой (при отношении H/He меньшем солнечного, т. е. $0,13 \pm 0,04$ по массе), за ней следует оболочка, состоящая в осн. из жидкого водорода, а с расстояния $\approx 0,5 R_0$ — оболочка из жемчужинчатого водорода. Металлич. водород заполняет слой до уровня $0,3 R_0$, где начинается ядро. Давление здесь достигает 10 Мбар. Ядро составляет $\approx 25\%$ по массе, что в неск. раз больше ядра Юпитера. Причём состоит в том, что ядром с шестью осевыми скачками пород в его состав, вероятно, входит значит. примесь ледяной компоненты (вода, аммиак, метан). В этом находит отражение тот факт, что С. занимает промежуточное положение между Юпитером, состоящим в осн. из водорода, и Ураном, Нептуном, в составе к-рых преобладает ледяная компонента, а водород составляет относительно небольшую фракцию.

Наличие у С. магн. поля, вероятно, связано с действием гидромагнитного динамо. Магн. поле на экваторе $\approx 0,21$ Гс. Замечат. особенностью состав. магн. поля планеты является его почти точная аксиальная симметрия, что, видимо, обусловлено сильным дифференциальным вращением наружных слоёв С. Отклонение осей магн. диполя от осей состав. вращения не превышает 1° .

С. получает от Солнца прибл. в 100 раз меньше тепла, чем Земля. Его эффективная температура составляет 95 К, что заметно выше равновесной (74 К). Это означает, что излучаемая С. в окружающее пространство энергии прибл. втрое больше энергии, получаемой от Солнца, и свидетельствует о высокой эффективности внутр. источника тепла. Наиб. вероятной природой этого источника может быть преобразование в тепло гравитач. энергии, высвобождающейся за счёт выпадения капель жидкого гелия (к-рые образуются при низкой темп-ре в жидком водороде) из внутр. оболочек к центру планеты.

Газ атмосферы С. понимают верх. часть его внутр. газовой оболочки. Хим. состав атмосферы С. существенно отличается от среднесолнечного. Кроме водорода и гелия, в состав атмосферы входят метан (CH_4), аммиак (NH_3), фосфин (PH_3), в небольших кол-вах присутствуют углеводороды (C_2H_2 и C_2H_4). Относич. содержания CH_4 , NH_3 , PH_3 , C_2H_2 и C_2H_4 составляют соответственно $2 \cdot 10^{-4}$; $2 \cdot 10^{-4}$; $3 \cdot 10^{-6}$; $8 \cdot 10^{-6}$ и 10^{-7} . Замечна обогащённость углеводом (входящим в состав соединений): отношение C/H больше солнечного в 2,3 раза,

Структура атмосферы, профили темп-ры и давления похожи на юпитерианские. Темп-ра в тропосфере на уровне с давлением 1 атм составляет ок. 145 К и медленно повышается с высотой (с адиабатич. градиентом $0,85 \text{ К км}^{-1}$). В тропосфере при давлении ок. $0,1 \text{ атм}$ темп-ра прилб. 80 К. Ниже неё расположено облака, к-рые, вероятно, состоят из виск. слёв; считается, что верхний видимый слой образован в осн. кристаллами аммиака, хотя этот факт нельзя считать окончательно установленным. Для атмосферы С. характерно наличие ряда динамич. образований (полос типа зон и поясов, пятен), родных его с Юпитером. Вместе с тем упорядоченная структура зон и поясов (отражающих систему планетарной циркуляции), а также наблюдаемые крупные пятна — овалы (ассоциируемых с крупными атм. вихрями) на С. выражена менее чётко из-за кратчайшего слоя надоблачной мелкодисперсной дымки. Размеры динамич. образований (вихрей и струй) велики по сравнению со шкалой высот ($\approx 60 \text{ км}$), но малы по сравнению с R_C и меньше аналогичных образований на Юпитере. В то же время скорости ветра на экваторе С. в деск. раз превышают скорости атм. движений в приэкваториальной зоне Юпитера, достигающая почти 500 м/с. Возможно, это связано с тем, что в систему циркуляции на С. вовлекаются более глубокие области атмосферы, где интенсивности передачи момента кол-ва движения в область экваториальных широт выше. Заметные различия динамики атмосфер С. и Юпитера определяются различием интенсивностей источников тепла в недрах этих планет, меньшим значением ускорения силы тяжести и большей толщиной наружной непрозрачающей молекулярной оболочки С. По этой же причине для атмосферы С. характерна меньшая по сравнению с Юпитером роль в передаче кинетич. энергии вихревых движений упорядоченным зональным течениям.

В ср. и верх. областях атмосферы С. важную роль играют фотохим. превращения; особенно это касается процессов с участием NH_3 , PH_3 и гидркарбонатов. Помимо солнечной радиации энергетич. источниками, обуславливающими рост темп-ры выше тропосферы, могут быть джоулев разогрев и диссипация энергии *энтултренинж* волн. Макс. электронная концентрация в ионосфере С. $\leq 2 \cdot 10^4 \text{ см}^{-3}$ на высоте $\sim 2500 \text{ км}$ (считая от уровня с давлением 1 атм). Магнитосфера С. по своей топологии и характеру процессов занимает промежуточное положение между магнитосферами Юпитера и Земли (см. *Магнитосфера планеты*). Близость маг. поля С. к дипольному проявляется в симметрии распределения зарядк. частиц во внутр. зоне его магнитосферы — как относительно оси вращения, так и относительно экваториальной плоскости, с к-рой практически совпадает положение нейтрального плазменного слоя. До радиальных расстояний (7—15) R_C плазма вращается практически синхронно с планетой. Плазма состоит из лёгких и тяжёлых ионов, вероятно, водорода, гелия, углерода, азота и кислорода. Их источником, помимо *солнечного ветра*, могут служить ледяные поверхности спутников С. и атмосфера Титана, орбита к-рого лежит внутри магнитосферы планеты. Наиб. устойчивые зоны захваченной радиации расположены в пределах $\leq 17 R_C$ на дневной и $\leq 20 R_C$ на ночной сторонах. Ударный фронт находится примерно на 25 R_C . Между магнитосферой и устойчивой зоной *радиационного пояса* (17—23 R_C) расположена область (зона псевдозахвата), где энергетич. спектр частиц становится очень мягким и наблюдаются конвективные потоки плазмы. На ночной стороне образуется протяжённый плазменный шлейф, на к-рый, вероятно, сильно влияют процессы, происходящие в межпланетной среде.

В систему С. входят окружающие его анемитивные кольца и 18 спутников. Кольца представляют собой единую плоскую систему небольшой толщины (менее километра), расположенную в экваториальной плоскости планеты. Выделяют 7 колец, основные из к-рых А, В

и С занимают область пространства между 1,2 и 2,3 R_C . Кольца обладают чрезвычайно сложной внутр. структурой: каждое из них состоит ещё из сотен индивидуальных колец. Эта динамич. структура, так же, как и более крупные промежуток внутри колец (деления), является следствием резонансов, обусловленных гравитационным взаимодействием колец с неравновесной фигурой планеты и её многочисл. спутниками. Наиб. заметны деления Кассини, Максвелла, Гюйгенса, Энке, Калдера. В радиальном направлении периодически наблюдаются тёмные и светлые образования («спиды»), существующие к-рых связывают с электростатич. эффектами, обусловленными наличием пылевых частиц внутри колец, погруженных в магнитосферу С. (с процессами в пылевой плазме). Внутри кольца С. расположено ближайшее к планете слабое кольцо D, у внеш. края кольца А ($\approx 2,3 R_C$) находится очень тонкое кольцо F, а за ним; вплоть до $\approx 8 R_C$, последовательно очень слабые кольца G и E. Общая масса колец $5 \cdot 10^{-9} M_C$. Размеры частиц, образующих кольца, прилб. от долей см до 5 м, состоят они в осн. из льда (гл. обр. водяного). Проблема их происхождения не решена — это либо реликты ранней стадии эволюции Солнечной системы, либо результат гравитационного взаимодействия С. с ядрами комет.

Все крупные спутники С., исключая Титан и Фобос, имеют ледяные поверхности. Низкие ср. плотности ($1,2—1,4 \text{ г/см}^3$) свидетельствуют о том, что эти тела почти целиком водно-ледяные; несколько больше отсюда содержание скальных пород у Мимаса, Дионы, Рея (размеры от 400—500 до 1500 км). Тем не менее на поверхности большинства спутников С. присутствуют характерные следы эндогенной активности, особенно сильно выраженные на Энцеладе. Этот факт пока не нашёл убедит. объяснения (наиб. вероятной причкой является диссипация приливной энергии вследствие наличия резонансов при орбитальном движении спутника в гравитацион. поле С.). Размеры открыты «Вояджером» малых спутников неправильной формы, находящихся в динамич. взаимодействии с более крупными спутниками и кольцами, прилб. от 30 до 190 км.

Наиб. интерес представляет самый крупный спутник С. — Титан, превышающий по размерам Меркурий (радиус Титана 2575 км, ср. плотность $1,9 \text{ г/см}^3$). Заметна особенность этого спутника — наличие у него мощной атмосферы (состоящей в осн. из азота) с давлением у поверхности $\approx 1,5 \text{ атм}$ и темп-рой $\approx 92 \text{ К}$. По-видимому, Титан состоит наполовину из льда и наполовину из скальных пород (силикатов, металлов). Собств. маг. поля Титан не имеет. На его поверхности с большой вероятностью присутствуют моря и озёра на метана и, возможно, океаны из этана. Из метана состоит и довольно плотные облака, из к-рых метан в виде дождя может выпадать на поверхность; предполагают, что круговорот метана на Титане аналогичен круговороту воды на Земле. В атмосфере Титана обнаружен богатый спектр простых органич. соединений, а сама атмосфера теряет атомарный и молекулярный водород и азот, что приводит к сложным процессам взаимодействия Титана с магнитосферой С. По характеру глобальной дымки и проявлению заметного *парникового эффекта* у поверхности Титан в чём-то напоминает Венеру, хотя определяющие эти свойства хим. состав и процессы иной природы. Лаб. моделирование и расчёты предсказывают, что при совр. скорости образования органич. веществ за время жизни Солнечной системы на Титане должен был образоваться слой такого материала толщиной не менее 100 м. Поэтому с Титаном связывают надежды обнаружить аналог первичного органич. вещества, к-рое могло существовать на ранней Земле.

Лит.: М а р о в М. Я., Планеты Солнечной системы, 2 изд., М., 1986; Saturn, ed. by T. Gehrels, M. Matthews, Tucson, 1984; Система Сатурна, пер. с англ., М., 1990.

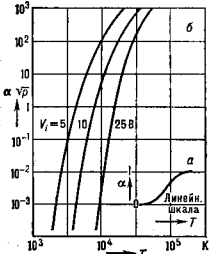
М. И. Мороз.

САХА ФОРМУЛА — фла, определяющая степень термич. ионизации в газе. Получена М. Н. Саха (М. N. S.

ба) в 1920 году объяснения ионизации в звёздных атмосферах. С. ф. относится к газу, находящемуся в состоянии термодинамич. равновесия, и имеет вид

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = 2 \frac{kT}{e} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \frac{p}{e} \exp(-W_e/kT),$$

где α — степень ионизации, т. е. отношение числа ионов атомов к общему числу всех атомов, T — абс. темп-ра, p — давление, равное парциальным давлений нейтральных атомов и ионов и электронов, W_e — энергия ионизации атома, k и e — статистич. веса нейтрального атома и иона, m — масса электрона, k — постоянная Больцмана, h — постоянная Планка (р.с.). С. ф. получена термодинамич. путём, аналогично у-р-нию равновесия для хим. диссоциации.

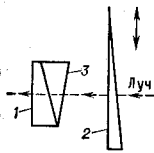


Зависимость степени ионизации газа α от темп-ры T и давления p : а — кривая $f(kT)$; б — кривые $\alpha\sqrt{p} = f(kT)$.

поверхности ионизация. Вывод С. ф. при указанных допущениях, основанный на термодинамич. положениях (исключая Нерста теорему), не рассматривает тех конкретных процессов ионизации и рекомбинации, к-рые, согласно *детального равновесия принципу*, обеспечивают динамич. равновесие между нейтральными атомами и ионами и электронами. Расчёты показали, что такими процессами при относительно низких темп-рах являются гл. обр. соударения быстрых молекул и фотоионизация, а при более высоких темп-рах — ионизация электронным ударом.

Лит.: Г р а н о в с к и й В. Л., Электрический ток в газе, т. 1, М.—Л., 1952; Э н и г е л ь А., Ионизованные газы, пер. с англ., М., 1959.

САХАРИМЕТР — поляризационный прибор для определения содержания сахаров (реже др. *оптически активных веществ*) в растворах по измерению угла вращения плоскости поляризации, пропорционального концентрации раствора. Компенсация вращения плоскости поляризации в С., в отличие от *поляриметра*, производится линейно перемещающимся кварцевым клином (рис.). При-



Кварцевый компенсатор: 1 — неподвижный клин из правовращающего кварца; 2 — подвижный клин из левовращающего кварца, соединённый со шкалой (её нулевая отметка соответствует подложному клину, при котором действия обоих кварцевых клиньев равны); 3 — клин из стекла (подклином), видимый для того, чтобы луч света, проходя через кварцевые клинья, не менял своего направления.

мещение кварцевого компенсатора позволяет освещать С. белым светом, т. к. кварц и сахар обладают почти одинаковой дисперсией *оптического вращения*. При измерении концентрации др. веществ, напр. камфоры,

их освещают монохроматич. светом. Опред. длины волны. Отсчёт угла вращения ведётся по линейной шкале, непосредственно указывающей процентное содержание сахара в растворе. Как и в поляриметрах, в С. при компенсации происходит уравнивание яркостей двух половин поля зрения, регистрируемое визуально или фотоэлектрически.

Во м. совр. С. с поляриз. модуляцией света кварцевый компенсатор и шкала связаны со следящей системой и компенсация измеряемого вращения плоскости поляризации осуществляется автоматич.

Лит.: Л а н д с б е р г Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; П и ш л о в с к и й А. А., Прикладная физическая оптика, М., 1981.

САХАРИМЕТРИЯ — метод определения концентрации растворов *оптически активных веществ* (гл. обр. сахаров, откуда назв. метода), основанный на зависимости вращения плоскости поляризации от концентрации раствора. С. применяется в пищевой и хим.-фармацевтич. промышленности.

СВЕРХВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ (СВЧ) — область радиодиагн. от 300 МГц до 300 ГГц, охватывающая дециметровые волны, сантиметровые волны и миллиметровые волны (см. *Радиоволны*).

СВЕРХВЫСОКИЙ ВАКУУМ — газовая среда с очень низкой плотностью газа, давление к-рого $p < 10^{-8}$ Па. В природе С. в. наблюдается в космич. пространстве, заполненном в осн. водородом с давлением $p \sim 10^{-12}$ Па. В окрестности Земли С. в. регистрируется на высотах более 800 км (10^{-8} Па на высоте 1200 км). В лаб. условиях достигнуто разрежение $p \sim 10^{-13}$ Па.

Необходимость и С. в. возникла в связи с разработкой *ускорителей заряженных частиц*, имитаторов космос. и приборов для исследования поверхности твёрдых тел. С. в. необходимо, чтобы исключить влияние окружающей газовой среды на состояние поверхности твёрдого тела в течение достаточно большого промежутка времени; напр., сохранение состояния атомно-чистой поверхности и её исследование в течение часа возможно при давлении $p \sim 10^{-8}$ Па (см. *Вакуум*).

Трудности получения С. в. связаны с тем, что кол-во газа, адсорбированного на поверхности (в стенках камер) и патающего из внеш. пространства (атмосферы), намного превосходит то кол-во, к-рое должно заполнять вакуумный объём при $p \sim 10^{-8}$ Па. Эти трудности растут с увеличением стеники необходимого разрежения, отключаемого объёма и сложности устройств, размещаемых в нём.

При получении С. в. необходимо: соблюдение т. в. вакуумной гигиены при изготовлении элементов прибора; применение разъемных соединений с металлами; уплотнителями; прогрев системы до темп-ры $T \sim 500^\circ\text{C}$; использование насосов с большой скоростью откачки и низким предельным давлением. В установке не должно быть материалов, упругих паров к-рых при 500°C превышает предельное разрежение, наиб. широко используются нержавеющие аустенитные стали. Разъемные соединения в прогретых системах должны обладать малой скоростью натекания и сохранять высокую надёжность при многократных циклах «нагрев — охлаждение». Этим требованиям наилучшим образом удовлетворяет соединение типа «ConFlat» (рис. 1).

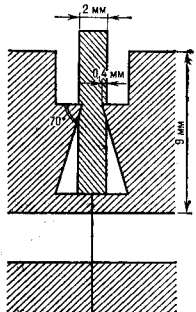


Рис. 1. Разъемное фланцевое соединение с металлическим уплотнителем.

Для получения С. в. обычно необходимы 3 ступени откачки: низковакуумная, высоковакуумная и сверхвысоковакуумная. Последняя включается после прогрева в высоком вакууме ($10^{-4} - 10^{-5}$ Па) всех частей системы, в т. ч. и сверхвысоковакуумных насосов. В качестве последних используют насосы со скоростью откачки до 10^6 л/с. Это турбомолекулярные, магниторазрядные, гетерионные, конденсационно-сорбционные (криогенные) насосы. Последние обеспечивают самое высокое предельное разрежение $\sim 10^{-11}$ Па. В турбомолекулярном насосе (рис. 2) в корпусе (1) с закрепленными дисками (2) вращается ротор (3), диски к-рого,

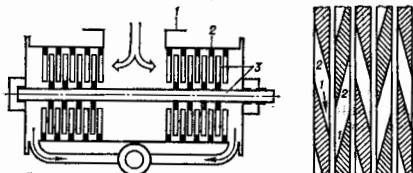


Рис. 2. Схема турбомолекулярного насоса.

как и диски статора 2, имеют косые прорезы ($>40^\circ$, рис. 2, б). При вращении ротора молекулы газа увлекаются в каналы, образуемые прорезами. Остаточное давление $\sim 10^{-8}$ Па. Действие магниторазрядного насоса основано на сочетании ионной откачки (ионизация и удаление ионов электр. полем) и поглощения газа распыляемым материалом катода (в результате ионной бомбардировки). Положит.

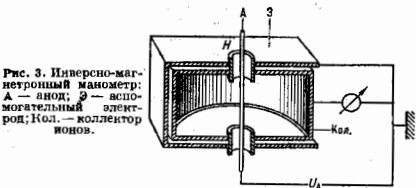


Рис. 3. Инверсно-магнетронный манометр: А — анод; Ф — вспомогательный электрод; Кол. — коллектор ионов.

ионы частично внедряются в катод, частично нейтронизируются и, попадая на анод, замораживаются распыляемыми частями катода. Гетерионные насосы основаны на сочетании поглощения химически активных газов с ионной откачкой инертных газов и углеводородов. В криогенных насосах происходит поглощение газа охлаждающей до низких темп-р поверхность.

Измерение С. в. вначале осуществлялось ионизационным манометром Байярда — Альберта, в к-ром газ ионизируется электронами, испускаемыми термокатодом, и измеряется ионный ток, пропорциональный давлению. По мере освоения области всё более низких давлений эти манометры уступили место инверсно-магнетронным манометрам (рис. 3). В них измерение сверхнизкого давления газа возможно благодаря использованию Пеминга разряда, возбуждаемого между холодными электродами в пост. магн. поле H . Подавление «паразитной» автоэлектронной эмиссии с поверхности коллектора, повышающей чувствительность прибора, обеспечивает вспомогат. электрод 3. При анодном напря-

жении ~ 6 кВ и магн. поле $2 \cdot 10^6$ Э, направленном вдоль оси анода, зажигание разряда и соответственно измерение С. в. происходит при давлениях 10^{-10} Па и ниже.

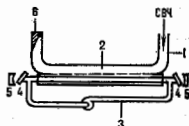
Техника С. в., кроме фундам. исследований, направленных на изучение атомной и электронной структуры частей поверхности, стимулировала развитие важных науч.-техн. направлений и методов (напр., молекулярно-пучковая эпитаксия, катализ, тонкопленочная микроэлектронная технология и др.).

Лит.: Глазков А. А. Сверхвысокий вакуум. Г. Л. Боннум электротехнических установок и комплексов, М., 1987, у з ст о л Д ж., Техника сверхвысокого вакуума, пер. с англ. М., 1988.

И. М. Осенин, СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РАЗРЯД — один из видов электрического разряда в газе, возбуждаемый быстропеременным электр. полем в диапазоне частот $f = 10^6 - 10^{11}$ Гц (длина волны $\lambda = 30$ см \div 3 мм). В зарубежной литературе этот разряд наз. микроволновым.

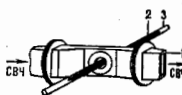
Способы возбуждения. По условиям возбуждения сверхвысокочастотные (СВЧ) разряды могут быть разделены на неск. видов. 1) Разряды в волноводах, возбуждаемые полями бегущей или стоячей эл.-магн. волны. При этом или сам волновод наполнен газом, или в него введены газоапоглощающие диэлектрики, трубки. На рис. 1 представлена схема С. р. в волноводе,

Рис. 1. СВЧ-разряд в волноводе: 1 — волновод; 2 — отверстие связи; 3 — трубка с проначкой; 4 — брестерские окна; 5 — лазерные вершины; 6 — радиопоглощающая нагрузка.



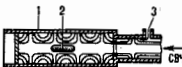
используемого для создания активной среды газового лазера. К разновидности волнового С. р. может быть также отнесен разряд, поддерживаемый поверхностной плазменной волной, возбуждаемой в пределах волновода (рис. 2). По такой схеме возбуждается ста-

Рис. 2. СВЧ-разряд в диэлектрической трубке, подерживаемый плазменной волной: 1 — волновод; 2 — плазма; 3 — диэлектрическая трубка.



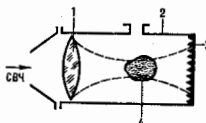
ционарный разряд в СВЧ-плазмотронах. 2) Разряды в резонаторах (рис. 3) возбуждаются также либо в газонаполненном втульнорезонаторной пространстве, либо в газонаполненном баллоне, расположенном внутри резонатора. Применение резона-

Рис. 3. СВЧ-разряд в резонаторе: 1 — резонатор; 2 — плазменный цилиндр; 3 — петля связи.



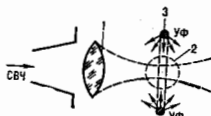
торов позволяет относительно просто получать в лаб. условиях разряды в сверхсильных сверхвысокочастотных электр. полях (до 10^6 В/см), для достижения к-рых в свободном пространстве используются генераторы на релятивистских электронных пучках. 3) С. р. в свободном пространстве возбуждаются пучками мощного СВЧ-излучения (рис. 4). Разновид-

Рис. 4. СВЧ-разряд в свободном пространстве: 1 — диэлектрическая линза, формирующая сходящийся СВЧ-пучок; 2 — вакуумная камера; 3 — радиопоглощающая нагрузка; 4 — плазма.



ностью такого разряда являются несамостоятельный разряд, в к-ром низовизм. состояние поддерживается внешним (неполюсным) источником, а энергия в ионизованную среду вводится с помощью сверхвысокочастотного электрич. поля, величина к-рого меньше порога пробоя (рис. 5). Разряды в пучках СВЧ-излучения ис-

Рис. 5. Несамостоятельный СВЧ-разряд в свободном пространстве: 1 — диэлектрическая линия; 2 — СВЧ-поле (меньше порога пробоя); 3 — кольцевой источник УФ-излучения.



пользуются в экспериментах, моделирующих локализированные искусственно ионизованные области над Землей, а также в плазмотронике для получения высококичтых продуктов реакции.

Пороги возбуждения. В СВЧ-разрядах энергия эл-маги. волн передается плазме. Под действием электрич. поля электроны приобретают кинетич. энергию, к-рая затем в соударениях с ионами и атомами переходит как в энергию теплового движения самих электронов, так и в энергию возбуждения и тепловую энергию массивных частиц.

Характер физ. процессов С. р. (пробой газовой среды, динамика разряда, пространственная структура и т. д.) зависит от соотношения между эфф. частотой соударений электронов с атомами и молекулами газа ν_m и частотой электрич. поля ω . При $\nu_m/\omega < 1$ (высокие частоты поля и низкие давления газа) электроны движутся в электрич. поле почти как свободные. При $\nu_m/\omega > 1$ (низкие частоты поля, высокие давления газа) электроны дрейфуют в перем. электрич. поле СВЧ-волны, $E(t) = E_0 \cos \omega t$, со скоростью $u_e = eE_0 \cos \omega t / m_e \nu_m$, т. е. в каждый момент движутся с той же скоростью, что и в пост. электрич. поле, напряженность к-рого равна в среднем значению перем. электрич. поля с амплитудой E_0 .

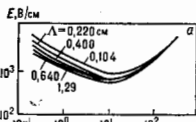
Энергия, приобретаемая электроном в СВЧ-поле,

$$W_e \approx e^2 E_0^2 / 2m_e \nu_m (\omega^2 + \nu_m^2), \quad (1)$$

где δ_e — ср. длина свободного пробега, переплаваемая электроном атому или молекуле при столкновении с ними.

На рис. 6 приведены эксперим. зависимости порога возбуждения E_0 самоподдерживающегося С. р. от давления рабочего газа p для разл. газов и при разных условиях. Зависимости всегда имеют минимум. На левой ветви, где порог падает с ростом давления, он тем ниже, чем больше размеры разрядного объёма, характеристические диффузионной длиной Λ (рис. 6,а), и чем

Рис. 6. Измеренные пороги СВЧ-пробоя: а — воздух, частота $f = 9,4$ ГГц; б — инертные газы, $f = 0,99$ ГГц, $\Lambda = 0,63$ см; в — нег-газ (газ с добавкой паров ртути), $\Lambda = 0,6$ см.



меньше частота поля f (рис. 6,а). То же относится и к самой величине минимума. На меньших частотах минимум располагается при более низких давлениях. На правой ветви, где порог растёт с повышением давления, зависимость порогового поля от размеров и частоты становится всё менее заметной и в пределе больших давлений почти совсем исчезает — все кривые асимптотически сливаются.

Теория вполне удовлетворительно описывает пороги характеристики С. р. Если СВЧ-поле включается достаточно быстро и параметры его сохраняются длит.

время (по сравнению с характерным временем развития ионизации), порог возбуждения СВЧ-разряда определяется след. «стационарным» критерием:

$$\nu_d(E_0) = \nu_d + \nu_d(E_0), \quad (2)$$

где ν_d — частота ионизации, ν_d — частота прилипания электронов к атомам и молекулам рабочего газа, ν_d — частота диффузионных потерь электронов ($\nu_d = D/\Lambda^2$, D — коэф. диффузии электронов).

В области высоких давлений диффузионные потери электронов незначительны и даже не слишком большая скорость ионизации обеспечивает пробой.

Т. к. при $\nu_m/\omega \ll 1$ энергия электронов (1) практически не зависит от ν_m и от давления, то с ростом давления и, следовательно, ν_m остаётся неизменной и частота ионизации ν_i . Однако с увеличением давления падает частота диффузионных потерь электронов, что приводит к уменьшению порогового электрич. поля E_0 . При $\nu_m/\omega \gg 1$ энергия электронов $W_e \approx (1/2)e^2 E_0^2 / m_e \nu_m \propto (E_0/p)^2$, т. к. $\nu_m \propto p$. Поэтому с ростом давления растёт величина порогового поля E_0 . Положение минимума кривой $E_0(p)$ можно установить на основании условия, разграничивающего предельные случаи $\nu_m \ll \omega$ и $\nu_m \gg \omega$, а именно, в случае равенства по порядку величин частот столкновений и поля: $\nu_m \approx \omega$.

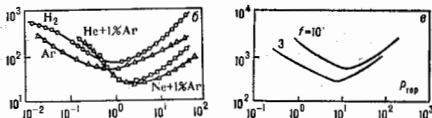
В условиях короткой длительности импульсы по порогу возбуждения разряда определяются «нестационарным» критерием: за время τ_1 лавины электронной с нач. концентрацией электронов n_0 должна достичь до нек-рой конечной величины n :

$$\nu_d(E_0) - \nu_d - \nu_d = \tau_1^{-1} \ln n/n_0. \quad (3)$$

Ур-ние (3) обобщает «стационарный» критерий (2) и сводится к нему при $\tau_1 \rightarrow \infty$. Обычно за конечную концентрацию принимается такая критич. концентрация $n_c = m_e(\omega^2 + \nu_m^2)/4n_e^2$, при к-рой плазменное образование отражает СВЧ-излучение, как металл. зеркало.

Для пробоя молекулярных газов при прочих равных условиях требуются более высокие поля, чем для атомарных, т. к. электрону приходится затрачивать энергию на возбуждение колебательных и др. более низколежащих электронных уровней в молекулах, и это тормозит набор энергии в поле. В электроотрицат. газах порог СВЧ-пробоя также высок, поскольку существуют дополнит. потери на прилипании.

Динамика сверхвысокочастотного разряда. Энергия СВЧ-волны, поглощаемая плазмой в разряде, передается атомам и молекулам, изменяя состояние газовой среды и меняя параметры самой плазмы в ходе развития газоразрядного процесса. Липш совокупность спец.



мер позволяет добиться стационарности плазменного образования, так необходимой в ряде приложений.

В совр. технике применяются и волноводные источники стационарной газоразрядной плазмы (СВЧ-плазмотроны). Разряд возбуждается и поддерживается СВЧ-излучением мощностью в деск. кВт в пересеченной волноводной диэлектрич. трубке с прокачиваемым через её объём газом. СВЧ-плазмотрон обладает высоким кпд — до 90%; разрядные условия близки к равновесным с темп-рой разрядной среды $T \approx 9000 - 10000$ К.

С. р., поджигаемые мощным импульсным СВЧ-излучением в свободном пространстве или внутри волноводов, обычно не горят в одном месте, а перемещаются навстречу излучению. В волноводах движение С. р. наблюдалось в широком интервале изменения давлений и плотностей потока СВЧ-излучения как в атомарных, так и в молекулярных газах и смесях. Если при $E_0 < E_c$ в отдалённом от излучателя конце волновода стимулируется пробой, напр. вводом усиливающего электрич. поле острая, по навстречу излучению распространяется волна ионизации, приводящая при достаточно длит. импульсе к выходу разряда на окон СВЧ-генератора. Скорости движения зависят от мощности СВЧ-излучения, рода газа и его давления и лежат в интервале $10^2 \div 10^4$ см/с. Наиб. скорости зарегистрированы в атомарных газах, наименьшие — в молекулярных.

Ионизационные волны характерны и для С. р. в свободном пространстве в сходящихся СВЧ-пучках. В надпороговых полях ($E_0 > E_c$) разряд в виде светящегося слоя толщиной $\sim \lambda$ со скоростью $10^2 \div 10^4$ см/с движется от места возникновения (фокальная плоскость) навстречу излучению. Скорость фронта ионизации зависит от рода газа, давления, поля СВЧ-волны и сходимости СВЧ-пучка. В полях $E_0 < E_c$ инициированный тем или иным способом разряд в виде неоднородного плазменного слоя с осевым размером $\sim \lambda$ «убегает» от инициатора навстречу излучению со скоростями $10^2 \div 10^4$ см/с, также зависящими от СВЧ-мощности, рода газа и давления.

В надпороговых полях динамика разряда определяется процессами, аналогичными оптическому пробую. Появление ионизационной волны связано с пространственной (аксиальной) неоднородностью пучка и падением амплитуды электрич. поля по мере смещения от фокуса к излучателю. Быстрая ионизация газа в области высоких полей и замедленная в области низких приводят к появлению кажущегося движения разряда вдоль оси с тем большей скоростью, чем слабее зависимость частоты ионизации от E_0 и тем меньше угол сходимости пучка. Аксиальный размер области свечения определяется величиной ослабления («скинирования») интенсивности пучка созданной им же газоразрядной плазмой.

Перенос ионизации осуществляется разл. механизмами: диффузией возбуждённых и заряд. частиц, за счёт теплопроводности, собственного ионизирующего излучения разряда и т. д. В зависимости от условий один к-л. процесс может играть определяющую роль, в соответствии с чем механизм распространения разряда наз. теплопроводностным, диффузионным, фотоионизационным (или радиационным), газодинамическим и др.

Устойчивость и пространственная структура сверхвысокочастотного разряда. Как стационарные, так и движущиеся навстречу волне С. р. характеризуются сложностью формы, прежде всего наличием мелкомасштабной пространственной неоднородности. Неоднородность разряда, как правило, тем существенней, чем выше отношение ω/ω_{pl} . Важную роль в формировании структуры разряда играют ионизационные неустойчивости, к-рые можно разделить на два класса: ионизационно-перегревные (или газодинамические).

Ионизационно-перегревные неустойчивости характерны для разреженных газов и высокой частоты ω . Физ. механизм возникновения этой неустойчивости основан на явления плазменного резонанса: пока величина электронной концентрации остаётся ниже критической ($n_e/n_c < 1$), её увеличение в тонком слое, вертикальном к направлению распространения увеличенной амплитуды поля ($E_0 \propto r^{-1}$, где r — диэлектрическая проницаемость плазмы; $\epsilon = 1 - 4\pi n_e^2/n_c^2 \omega^2$). Это, в свою очередь, приводит

к возрастанию частоты ионизации ν_i и, следовательно, к дальнейшему росту n_e . В результате в первоначально однородном разряде образуются плоские неоднородные слои (страты), перпендикулярные вектору электрич. поля (см. также *Низкотемпературная плазма*).

Ионизационно-перегревные неустойчивости связаны с ростом скорости ионизации при увеличении тем-ры и характерна для высоких давлений газа и малых частот СВЧ-излучения. Физ. механизм этой неустойчивости заключается в следующем: в области локального флуанкта. роста концентрации электронов повышается энерговыделение, растёт тем-ра газа, падает концентрация молекул (атомов) рабочего газа и, соответственно, растёт частота ионизации ν_i , что приводит к дальнейшему росту концентрации n_e . Развитие неустойчивости приводит к распаду первоначально однородного разряда на отделившиеся (шнурки), вытянутые вдоль электрич. поля. Замети. волновая природа возбуждающего разряда излучения сказывается на периодичности возникновения шнуров и на параметрах плазмы, достижимых на конечной (нелинейной) стадии развития неустойчивости. Характерная фотография разряда в газе высокого давления в пучке СВЧ-волн, демонстрирующая сложную структуру плазменного образования в результате развития неустойчивости, приведена на рис. 7.

Вторичноэлектронные вакуумные сверхвысокочастотные разряды (ВЭР). К С. р. относятся в т. ч. вторичноэлектронные (или «мультипликаторные») разряды, развивающиеся в вакууме у поверхности взаимодействующих с СВЧ-излучением металлич. электродов, стенок волноводов и резонаторов, диэлектрич. преград. Явление ВЭР состоит в лавинообразном росте электронной концентрации у одиночной поверхности (односторонний разряд) или между двумя поверхностями (двусторонний разряд). Разряд развивается за счёт вторичной электронной эмиссии. ВЭР ограничивает интен-

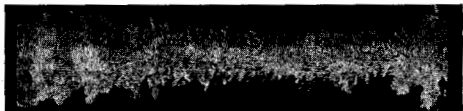


Рис. 7. Фотография СВЧ-разряда в воздухе, возбуждаемая пучком СВЧ-волн; $f = 37$ ГГц; давление $p = 300$ мм рт. ст.

сивность излучения мощных генераторных СВЧ-приборов, развиваясь в объёме самого прибора, на его выходных окнах или в элементах транспортирующего излучение тракта.

Применение. С. р. широко применяются в совр. технике. Ряд плазменных процессов, таких, как получение чистого кварца, разл. соединений металлов, связывания азота с кислородом в воздухе, диссоциация углекислого газа и др., с высокой эффективностью протекает в разрядах, возбуждаемых СВЧ-полем. Преимуществом СВЧ-разрядов в плазменных прежде всего связаны с возможностью построения реакторов для получения особо чистых веществ.

Относительно высокая устойчивость и специфичность вида функции распределения электронов по энергиям обуславливают использование С. р. в технике молекулярных эсимерных и др. газоразрядных лазеров.

Уникальные свойства СВЧ-диапазона, позволяющие с мин. потерями передавать энергию по трассе Земли — космос с включением атм. участка, лежат в основе ряда проектов использования мощных СВЧ-пучков для создания свободно локализованных искусств. плазменных областей в атмосфере.

Лит.: Микин Д. и Янд А., Сверхвысокочастотный пробой в газах, пер. с англ., М., 1969; Батагов Г. М. и др., СВЧ разряды высокого давления, «Труды ФИАН», 1985, т. 160, с. 174; Рабаев Ю. П., Физика газового разряда, М., 1987;

СВЧ-генераторы плазмы. М., 1988; Высокочастотный разряд в волновых полях. Сб. науч. трудов, Горький, 1988.

СВЕРХГЕНЕРАТОР (супергенератор) — периодически запускаемый автогенератор (или параметрон), используемый обычно как приёмник радиосигналов в УКВ-диапазоне (см. *Радиоволны*). Запуск и срыв колебаний С. производится либо напряжением от отд. УЗ-генератора (генератор гашения), периодически изменяющего коэф. усиления в цепи обратной связи автогенератора, либо С. работает в режиме автомодуляции. Различают линейный и нелинейный (логарифмический) режимы С. В линейном режиме макс. амплитуда импульса генерации С. линейно зависит от амплитуды принимаемого сигнала. В нелинейном режиме от амплитуды принимаемого сигнала зависит приращение площади импульса, а его макс. амплитуда остаётся практически постоянной. В обоих режимах полезная модуляция выделяется после детектирования последовательности импульсов, генерируемых С. Форма частотной характеристики С. зависит от нач. напряжения, определяющего нарастание очередного импульса генерации С. Если возбуждение импульса начинается от уровня шумов в контуре С., то частотная характеристика имеет колоколообразную форму с гладкой обгибающей (некогерентный режим). Если возбуждение определяется затухающим напряжением предыдущего импульса, то частотная характеристика имеет гребенчатую форму, т. е. в С. имеет место резонанс на частотах, отстающих от частоты заполнения импульсов на величину кратную частоте гашения (когерентный режим). С. присущи высокий коэф. усиления в сравнительно высокий уровень собственных шумов. В параметрическом С. (ПС) путём модуляции напряжения на диоде периодически запускается параметрич. генератор (параметрон). Фаза установившихся колебаний в импульсе ПС может принимать лишь дискретные значения по отношению к фазе напряжения накачки, к-рые определяются фазой принимаемого сигнала. Поэтому для регистрации сигнала в ПС можно применять фазовый детектор. С. используются также в *радиоспектроскопии* для регистрации сигналов ИМР и ЯМР.

Лит.: К о м о в о в В. П., Т р о ф и м е в к о И. Г., К в и н - т о в с к и е ф а з ы при обнаружении радиосигналов. М., 1978; С в е р х - г е н е р а т о р ы, М., 1983.

СВЕРХГИГАНТЫ — наиб. яркие звёзды, светимость которых превышает $\sim 10^4 L_{\odot}$ и может достигать $(2-3) \cdot 10^6 L_{\odot}$ (L_{\odot} — светимость Солнца). По двумерной спектральной классификации С. описываются как объекты *светимости классов Ia⁺, Ia, Iab, Ib* (звёзды класса Ia⁺ иногда именуются также гигантантами или сверхгигантантами). Традиционно С. подразделяются на голубые (*спектральных классов O, B и A*), жёлтые (*F, G*) и красные (*K и M*), см. также *Красные гиганты и сверхгиганты*. По эмпирич. оценкам массы С. достигают 50–60 M_{\odot} , однако возможно существование объектов с массой до $\approx 100 M_{\odot}$. Радиусы С. составляют от $\sim 10 R_{\odot}$ у звёзд ранних спектральных классов до $\sim 1000 R_{\odot}$ у звёзд наиб. поздних спектральных классов. Кроме того, С. поздних классов обладают пылевой оболочками, протяжённость к-рых может достигать вёск. тысяч светов. радиусов звёзд.

У большинства С. наблюдается спектральная и фотометрич. переменность разл. масштабов и периодичности, колебания блеска. Эти явления связаны с неустойчивостью протяжённых оболочек, пульсациями звёзд, прохождением через оболочки ударных волн, нерегулярными движениями больших областей атмосферы С.

Звёзды с массами от $\approx 5 M_{\odot}$ до $\approx 12 M_{\odot}$ попадают в область *Герцицинуа — Рессела диаграмм*, занимаемую С. (т. е. становятся С.), на наб. поздних стадиях своей эволюции, когда у них формируются углероднокислородные ядра, окружённые тонкими слоевыми источниками энерговыделения (см. *Джозифов звёзд*). Мелкие массивные звёзды никогда не достигают стадии С.

Звёзды с массами от $\approx 12 M_{\odot}$ до $(40 \pm 10) M_{\odot}$ проводят в области С. практически всё своё время жизни, более массивные звёзды покидают область С. в конце или после завершения стадий горения водорода в ядре.

Одним из осн. факторов, определяющих эволюцию С., является потеря вещества, скорость к-рой составляет от $\sim 10^{-8} M_{\odot}/\text{год}$ у звёзд спектрального класса А до $\sim 10^{-5} M_{\odot}/\text{год}$ у звёзд наиб. ранних и наиб. поздних спектральных классов. У горячих С. истечение вещества происходит под действием давления излучения в резонансных линиях в УФ-области спектра, у наб. холодных С. — под действием давления излучения на пыль и молекулы, к-рые передают импульс газу. Механизм потери вещества объектами промежуточных спектральных классов пока не вполне ясен. С. с массами, меньшими $\approx 10 M_{\odot}$, в результате потери вещества превращаются в окружающие плотными газопылевыми оболочками т. н. ОН/IR-звёзды, излучающие преим. в ИК- и радиодиапазонах спектра, затем — в ядра *лазарных туманностей* и оканчивают эволюцию белыми карликами. С. с массами от $\approx 10 M_{\odot}$ до $(40 \pm 10) M_{\odot}$ к моменту выгорания в их недрах ядерного горячего обладают протяжёнными оболочками и взрываются как *сверхновые звёзды II типа*, образуя нейтронные звёзды. Более массивные С. теряют оболочки на стадиях горения водорода в ядре и покидают область С. на диаграмме Герцицинуа — Рессела, становясь горячими гелиевыми *Вольфа — Райе звёздами*. Последние, завершив эволюцию, также взрываются как сверхновые (типа Ib), образуя нейтронные звёзды и, возможно, чёрные дыры.

Для С. поздних спектральных классов характерны многочисл. аномалии хим. состава, связанные с проникновением конвекции из оболочки в область интенсивного ядерного горения, где происходит синтез хим. элементов. При взрывах С. как сверхновых и выбросах при облобках происходит *обогащение межзвёздной среды тяжёлыми элементами*.

Лит.: Я г е р К. е. Звёзды наибольшей светимости, пер. с англ., М., 1984.

Л. Р. Юнгелсон.

СВЕРХДАЛЬНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН — распространение радиоволн на расстояния, существенно превышающие протяжённости стандартных линий радиосвязи (≤ 10 тыс. км). Реализуется при благоприятном пространственном распределении электронной концентрации N_p и эфф. частоты соударений ν над землёй на уровне $\sim 70 \div 400$ км, определяющих совместно с рабочей частотой f осн. свойства показателя преломления земной атмосферы и формирующих такой волновой канал (см. *Волновое распространение радиоволн*), к-рый обеспечивает наим. затухание в точке приёма. При этом существует роль играют высотная стратификация среды и её горизонтальная неоднородность.

Представление о предельно достижимой дальности менялось с накоплением эксперим. фактов, развитием приёмно-передающих комплексов в теории распространения дл.-магн. волн. Первые опыты Г. Маркони (G. Marconi) по трансатлантич. связи (1901) продемонстрировали неожиданно высокую напряжённость поля и привели А. Кеннелли (A. Kennelly) и О. Хевисайда (O. Heaviside) к гипотезе о существовании *ионосферы*, отражающей радиоволны обратно к Земле (см. *Отражение радиоволн*). Освоение в 1920-е гг. КВ-диапазона (декаметрового) показало возможность установления дальних связей даже при малых излучаемых мощностях. Были обнаружены сигналы, проходящие по обратной дуге большого круга и кругосветное эхо, отмечено повышение амплитуды сигнала в окрестности антропоид излучателя. Дальнейшие исследования, в т. ч. с помощью ИСЗ, геофиз. ракет и острованных *радиотелескопов*, показали наличие разнообразных каналов С. р., множественность траекторий, сложные вариации азимутальных углов прихода, связь оптич. угловый распространения с освещённостью трассы. Эти ис-

следования позволяют классифицировать сигналы С. р. по следующим типам: прямые и сигналы (ПС) — длина радиотрассы D от 10 до 20 тыс. км; обратные сигналы (АС) — $D \sim 20$ тыс. км; обратные сигналы (ОС) — $20 < D < 40$ тыс. км; кругосветные сигналы (КС) — $D \sim 40$ тыс. км; кратные кругосветные сигналы (КС_к) — $D \sim 40$ л. тыс. км. К сигналам С. р. относят также задержанные сигналы, эхосигналы с многосекундными задержками (ЗС).

Прямые и обратные сигналы. При расстоянии между корреспондентами $\sim 10-15$ тыс. км в суточном цикле наблюдается режий переход от кратчайшего пути (ПС) к обратной трассе (ОС). При этом предпочтительной является трасса, большая часть к-рой лежит в ночном полушарии. Реверс передающей и приёмной антенн на таких трассах способствует повышению надёжности связи.

Антиподные сигналы (АС) соответствуют макс. разности залучателя и приёмника на Земле, когда потенциально возможны любые направления прихода радиоволн. Из-за неоднородности ионосферы вблизи антипода формируется фокальное пятно размером $\sim 0,5-1,5$ тыс. км с неск. направленными приходами и сложным пространственным распределением напряжённости поля. Это явление аналогично *абберациям оптической систем*. Опт. условия приёма АС реализуются на трассах, лежащих в ночном полушарии и в окрестности терминатора (линия, отделяющая дневное полушарие от ночного). АС меньше др. типов сигналов подвержены влиянию ионосферно-магн. возмущённости и поглощению в полярных зонах.

Кругосветные сигналы (КС). Опт. трассы тяготеют к сумеречной зоне, составляя обычно с терминатором угол $10-20^\circ$. Наилучшие условия приёма КС зимой в дневное время, неск. хуже — в ночное время летом и днем в равноденствие. Амплитуда КС практически не меняется при реверсе передающей и приёмной антенн. С ростом солнечной активности приём КС улучшается. Диапазон рабочих частот f — $10-30$ МГц с опт. частотами порядка $15-22$ МГц. Осн. особенности КС являются стабильность времени распространения ($138-140$ мс), наличие опт. азимута, ортогонального направлению на подсолнечную точку (см. *Магнитосфера Земли*). Более точные условия приёма КС сводятся к след. вышпр. правилам: критич. частота F -слоя ионосферы в районе залучателя и его антипода $f_{кр} \geq 1/3$; траектория КС близка к большому кругу, на к-ром достигается максимум минимуму $f_{кр} F^2$ и минимум продольным градиентам электронной концентрации. При связи между ИСЗ, орбиты к-рых проходят ниже максимума F -слоя, диапазон наблюдаемых частот расширяется до 40 МГц, и вероятность приёма дальних радиосигналов значительно увеличивается.

Кратные кругосветные сигналы (КС_к). Опт. условия приёма КС_к, как и КС, соответствуют сближению трасс с терминатором. КС_к принимаются в периоды высокого уровня КС. Обращает на себя внимание исключительно низкое затухание КС_к — порядка $5-20$ дБ на один обход.

Задержанные сигналы (ЗС). *Радиозво* с задержками в единицы и десятки секунд (т. е. на $1-2$ порядка больше, чем у КС) наблюдается гораздо реже, чем КС. В ряде случаев опт. условия приёма ЗС также связаны с терминатором и отмечается кратность их задержек задержкам КС.

Явление С. р. р. наиб. характерно для коротких (декаметровых) волн в диапазоне $f \sim 10-25$ МГц. Волны более низкой частоты испытывают аналит. поглощение в ионосфере, а их излучение требует *радиопередаточных устройств* большой мощности и громоздких антенн. Для УКВ и более коротких радиоволн, как правило, рефракция в ионосфере недостаточна для формирования устойчивого волнового пакета. Предель-

ная частота вырождения (разрушения) волновода определяется верх. границей частотного диапазона С. р. р. Для С. р. р. всех типов можно отметить ряд общих свойств. Диапазон опт. частот расширяется в годы высокой солнечной активности. Вертикальные углы прихода радиоволн лежат в пределах $5-20^\circ$ от горизонта. Для трасс длиной порядка $15-20$ тыс. км азимутальный угол прихода меняется плавно со временем, значительно отклоняясь в переходные периоды от дуги большого круга.

Механизмы сверхдальнего распространения радиоволн. Осн. способом С. р. р. декаметровых радиоволн является смешанный механизм распространения, включающий в себя с к а ч о в ы й (последователь. отражение радиоволн от поверхности Земли и ионосферы) и в о л н о в о д ы й способы распространения. Приближённые ф-лы для диэлектрич. проницаемости

$$\epsilon_0 = 1 - 4\pi e^2 N_e / m(\omega^2 - \nu^2)$$

и проводимости плазмы

$$\sigma \approx e^2 N_e \nu / m(\omega^2 - \nu^2),$$

где $\omega = 2\pi f$ — циклическая частота, m — масса электрона, позволяющая оценить частотно-угл. диапазоны волн, удерживаемых в волноводе Земли — ионосфера, и их поглощение. Слабее всего затухают волны высокой частоты, распространяющиеся в приподнятом волновом канале, формирующемся ниже максимума F -слоя за счёт сферичности Земли и рефракции радиоволн в расщепленной ионосфере (рис. 1). Такими волноводорикошетирующими модами осуществляется сверхдальняя связь между ИСЗ. Малое погонное затухание КС и КС_к говорит о том, что реализуется волноводный механизм распространения. Оценки показывают, что ионосферный волновод возбуждается с Земли за счёт регулярных горизонтальных градиентов ионосферы, рассеяния на случайных неоднородностях и дифракционных эффектах.

Геом. оптика распространения радиоволн в трёхмерно-неоднородной ионосфере подобна динамике частицы в медленно меняющемся потенциальном поле. В первом приближении вертикальная проекция лучевой траектории $r(\theta)$ дается ур-нием

$$\frac{1}{R} \int \frac{dQ}{d\theta} \frac{ds}{\sqrt{Q}} = \pm \frac{dQ}{d\theta} \int \frac{dr}{\sqrt{Q}}. \quad (1)$$

Здесь $r = R + z$ — расстояние от центра Земли, R — радиус Земли, z — расстояние вдоль земной поверхности; $\epsilon = (\epsilon^2 R^2) \epsilon_0(r, \theta, \varphi)$ — модифициров. диэлектрич. проницаемость, $Q = Q(\theta, \varphi)$ — медленно меняющаяся ф-ция географич. координат, определяемая из условия сохранения адiab. инварианта:

$$I = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{\epsilon - Q} dr / r = \text{const} \quad (2)$$

(здесь r_1, r_2 — точки поворота луча). Ф-лы (1) и (2) учитывают горизонтальную неоднородность ионосферы и позволяют проследить переход от скачкового механизма к волноводному распространению и обратно (рис. 2). Ф-ция $Q = \cos^2 \beta$ определяет вертикальный угол прихода β для скачковых траекторий; для волноводорикошетирующих траекторий $Q > 1$. Её максимум достигается на предельной рабочей частоте

$$f_{\text{макс}} = \frac{e}{\sqrt{\pi m}} \sqrt{N_e(r_0) + (r_0/2) dN_e(r_0)/dr} \quad (3)$$

выходящегося ионосферного волновода на уровне $r = r_0$, определяемом из ур-ния

$$dN_e(r_0)/dr + (r_0/3) d^2 N_e(r_0)/dr^2 = 0. \quad (4)$$

(суточные и сезонные изменения ионосферы, сезонные изменения свойств земной поверхности, ионосферные возмущения, изменение метеорологич. условий и т. д.). Это и обуславливает применение СДВ в глобальных радиосистемах высокой точности и надежности несмотря на необходимость использования излучающих антенных систем больших размеров и более высокую стоимость передачи информации. Кроме того, радиоволны этого диапазона обладают большой глубиной проникновения в проводящую среду, что делает возможным их применение для связи с погруженными в морскую воду и в толщу земли объектами (см. *Распространение радиоволн*).

Распространение СДВ в земных условиях происходит в сферич. волноводном канале, образованном Землей и ионосферой (см. *Волноводное распространение радиоволн*). На отражение СДВ от ионосферы оказывает влияние её ниж. часть — существование для отражения область располагается на высотах 60—80 км днём и 80—100 км ночью. В этой области высот на очень низких частотах ионосфера представляет собой неоднородную проводящую среду, проводимость к-рой резко возрастает с высотой и приобретает, начиная с высоты 75 км, заметно выраженный анизотропный характер вследствие влияния магн. поля Земли. В дневных условиях влияние магн. поля Земли на отражение СДВ и их распространение в приземном волноводном канале, однако ночью оно оказывается существенным. При отражении от анизотропной ионосферы в отражённом поле возникают компоненты, отсутствовавшие в падающей волне, что является причиной ошибок в системах радионавигации. Наличие анизотропии приводит к зависимости характеристик эл.-магн. поля от азимута траектории распространения и к появлению невязанности — изменению характеристик поля при изменении направления траектории распространения на обратное.

СДВ хорошо отражаются от ионосферы и от земной поверхности, что и приводит к их слабому затуханию при распространении в приземном волноводном канале. При изучении молниевых разрядов осн. часть их энергии распространяется в приземном волноводном в виде эл.-магн. импульса, называемого *атмосфериком*, а просачивающаяся через ионосферу часть эл.-магн. излучения образует т. н. свистящие атмосферерики, спектр к-рых лежит в диапазоне 1—10 кГц.

Для описания и расчёта полей СДВ в волноводном канале Земли — ионосфера применяют 2 их осн. представления — разложение в виде суммы земной и однократно и многократно отражённых от ионосферы волн и разложение в виде ряда нормальных волн. Первое из них удобно для расчёта поля СДВ на расстояниях от излучателя не более неск. сотен км, когда число отражённых от ионосферы волн, влияющих на полное поле, мало (една или две волны). Для описания поля СДВ на больших расстояниях используется ряд нормальных волн, число существ. членов в к-ром уменьшается с увеличением расстояния.

Лит.: Геллер И., *Terrestrial radio waves*, N. Y., 1949; Красущик И. Е., Яблочкин Н. А., *Теория распространения сверхдлинных волн*, 2 выд., М., 1963; Макаров Г. И., Юзиков В. В., Орлов А. В., *Современное состояние исследований распространения СДВ в волноводном канале Земли — ионосфера (обзор)*, «Изв. ВУЗов. Радиофизика», 1970, т. 13, № 3, с. 321. Г. И. Макаров, В. В. Юзиков.

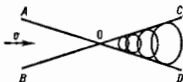
СВЕРХЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ — скорость движения среды или тела в среде, превышающая скорость звука в данной среде.

СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ — течение газа, в к-ром в рассматриваемой области скорости v его частицы больше местных значений скорости звука a . С течением С. т. связан ряд важных практич. проблем, возникающих при создании самолётов, ракет, снарядов со сверхзвуковой скоростью полёта, при создании высоконапорных компрессоров, паровых и газовых турбин, эжекторов, *аэродинамических труб* для получения потока со сверхзвуковой скоростью и др.

Наиб. развитие получило исследование установившихся С. т. при обтекании однородным потоком тел и при движении газа в разл. каналах, соплах и в струях. Установившиеся С. т. газов, термодинамич. состояние к-рых характеризуется двумя величинами, напр. давлением p и плотностью ρ , описываются в общем случае системой пяти квазилинейных дифференц. ур-ний в частных производных гиперболич. типа с тремя независимыми пространственными переменными x_1, x_2, x_3 ; искомыми величинами являются три составляющие вектора скорости v_1, v_2, v_3 , давление p и плотность ρ (или энтропия S). При изучении С. т. важная роль принадлежит попятно характеристик системы дифференц. ур-ний.

С. т. газа имеет ряд качеств, отличных от дозвуковых течений. Т. к. слабое возмущение в газе распространяется со скоростью звука, то влияние слабого изменения давления, вызываемого помещённым в равномерный сверхзвуковой поток источником возмущений (напр., телом), не может распространяться вверх по потоку, а сводится вниз по потоку со скоростью $v > a$, оставаясь внутри т. н. конуса возмущений *COD* или конуса Маха (рис. 1). В свою очередь, на данную точку

Рис. 1. Конус возмущения *COD* и конус влияния *AOB*.



О потока могут оказывать влияние слабые возмущения, идущие только от источников, расположенных внутри конуса *AOB* с вершиной в данной точке и с тем же углом при вершине, что и у конуса возмущений, но обращённого противоположно ему (т. н. конус влияния).

Если установившийся поток газа неоднороден, то области возмущений и области влияния, построенные для каждой точки, ограничены не прямыми круглыми конусами, а коноидами — конусовидными криволинейными поверхностями с вершиной в данной точке. С матем. точки зрения эти поверхности и являются характеристиками системы дифференц. ур-ний с частными производными, описывающей движение газа (см. *Газовая динамика*). Через характеристику или поверхность, принадлежащую огибающей к-л. однонаправленной семейств характеристик, решение ур-ний может быть продолжено непрерывным образом бесчисленным количеством способов, т. е. к-л. одно течение газа может через характеристику соединяться непрерывным образом с разл. течениями (при этом будут терпеть разрыв производные к-л. порядка от скорости, давления и плотности газа по нормали к характеристике). Величина составляющей скорости газа по нормали к характеристике равна местному значению скорости звука. Существование особенностей С. т. обусловлены нелинейностью системы ур-ний газовой динамики и зависимостью т. н. *импеданса акустического* ρa от термодинамич. состояния среды.

При распространении по газу волны, вызывающие повышение и понижение давления, имеют разный характер. Волна, вызывающая повышение давления, распространяется по газу, превращается в очень узкую область (с толщиной порядка длины свободного пробега молекул), к-рую для мн. целей теоретич. исследования заменяют поверхностью разрыва — т. н. *ударной волной* или скачком уплотнения. При прохождении газа через ударную волну его скорость, давление, плотность, энтропия меняются разрывным образом — скачком. Согласно 2-му началу термодинамики (гребующему, чтобы энтропия при адиабатич. процессах не убывала), следует, что возможны лишь такие скачки, в к-рых давление и плотность газа возрастают, т. е. скачки уплотнения, а скачки разрежения, допускаемые законами сохранения массы, импульса и энергии и приводящие к уменьшению давления и плотности, по

противоречащие 2-му началу термодинамики (т. е. энтропия должна уменьшаться), — невозможны (теорема Цемилена).

Скачок уплотнения (ударная волна) распространяется по газу со сверхзвуковой скоростью, тем больше, чем больше интенсивность скачка, т. е. чем больше повышение давления и в нём. При стремлении интенсивности скачка к нулю скорость его распространения приближается к скорости звука. Векторы скорости частицы газа до и после прохождения ею скачка уплотнения и нормаль к элементу скачка уплотнения, сквозь который проходит частица, лежат в одной плоскости. При заданной скорости набегающего потока компоненты скорости газа за скачком в этой плоскости связаны соотношением, геом. интерпретацией к-рого является т. н. ударная полнота, позволяющая к-рой легко определить скорость газа после скачка, если известен угол поворота потока в скачке.

При установившемся С. т. вдоль стенки с изломом (рис. 2,а) возмущения, идущие от всех точек линии излома, ограничены отбегавшей козусов возмущений — плоскостью, наклонённой к направлению потока под углом μ , таким, что $\sin \mu = a/b$.

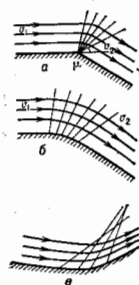


Рис. 2. Обтекание сверхзвуковым потоком: а — стенки с изломом; б — выпуклой искривлённой стенки; в — вогнутой стенки.

ка стенки. В этих течениях, называемых течениями Прайдля — Майера, параметры газа постоянны вдоль плоских характеристик. Давление и плотность газа в таком течении при движении уменьшаются. При удалении от стенки градиенты этих величин вдоль линий тока уменьшаются. Напротив, если стенка имеет вогнутый участок (рис. 2,а), то прямолинейные характеристики сближаются и градиенты давления и плотности вдоль линий тока при нек-ром удалении от стенки неограниченно возрастают, в потоке возникает скачок уплотнения.

При обтекании сверхзвуковым потоком клина (рис. 3,а) поступат. течение вдоль боковой поверхности клина отделяется от набегающего потока плоским козусом скачком уплотнения, идущим от вершины клина (т. н. головная ударная волна), скорость потока за скачком определяется по ударной волне; для клина конечной длины из двух возможных значений скорости осуществляется большее. При углах раскрытия клина, больших нек-рого предельного, подобное простое течение невозможно. Скачок уплотнения становится криволинейным, отходит от вершины клина, превращаясь в отходящую ударную волну, и за ней появляется область с дозвуковой скоростью те-



Рис. 3. Обтекание сверхзвуковым потоком: а — клина; б — затупленного тела.

чения газа в ней. Это характерно для сверхзвукового обтекания тел с тупой головной частью (рис. 3,б).

При обтекании сверхзвуковым потоком пластины (рис. 4) под углом атаки α , меньшим ноль, при к-ром скачок отходит от передней кромки пластины, от её передней кромки вниз идёт плоский скачок уплотнения, а вверх — течение разрежения Прайдля — Майера. В скачке и в волне разрежения поток поворачи-



Рис. 4. Схема обтекания пластины сверхзвуковым потоком.

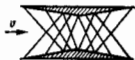
вается, обтекая затем пластину. На верх. стороне пластины давление ниже, чем под пластиной; вследствие этого возникает *подъёмная сила* и сопротивление, т. е. *Д'Аламбера — Эйлера парадокс*, не имеет места. Причиной того, что, в отличие от дозвукового обтекания, при сверхзвуковой скорости обтекания идеальным газом тела испытывают сопротивление, служит возникновение скачков уплотнения и связанное с ними увеличение энтропии газа при прохождении им скачков. Чем больше возмущения вызывает тело в газе,

Рис. 5. Тела, обладающие равным сопротивлением при большой сверхзвуковой скорости.



тем интенсивнее ударные волны и тем больше сопротивление движению тела (рис. 5). Для уменьшения сопротивления тел при сверхзвуковых скоростях может быть использован принцип интерференции возмущений, идущих от разл. частей тела или от разл. тел системы,

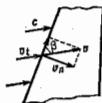
Рис. 6. Выплан Буземана.



напр. как в случае выплана Буземана (рис. 6), к-рый обладает нулевым сопротивлением, но не имеет и подъёмной силы.

Для уменьшения сопротивления, связанного с образованием головных ударных волн, при сверхзвуковых скоростях пользуются стреловидными (рис. 7) и тре-

Рис. 7. Схема обтекания стреловидного крыла.



угольными крыльями, передняя кромка к-рых образует острый угол β с направлением скорости v набегающего потока. Волновое сопротивление крыла бесконечного размаха обратится в нуль, когда угол скольжения β крыла достигает такой величины, что нормальная к кромке крыла составляющая скорости v_n станет дозвуковой.

Аэродинамически совершенной формой (т. е. формой с относ. малым сопротивлением давлению) при сверхзвуковой скорости является тело, нормаль к поверхности к-рого мало отклоняется от плоскости, перпендикулярной к направлению движения, т. е. тонкое,

заостренное с концов тело, движущееся под малыми углами атаки. При движении таких тел с умеренной сверхзвуковой скоростью (когда скорость полета превосходит скорость звука в небольшое число раз) производимые ими возмущения давления и плотности газа и возникающие скорости движения частиц газа малы. Для этих условий разработана теория, основанная на линеаризации уравнений движения сжимаемого газа и позволяющая определить аэродинамич. характеристики профилей крыла, тел вращения, крыльев конечного размаха. К особенно простым соотношениям эта теория приводит в случае установившегося обтекания крыла бесконечного размаха (профиля). При таком обтекании избыточное давление, производимое потоком со скоростью v на каждый элемент поверхности крыла, равно $\rho v^2 \theta / \sqrt{M^2 - 1}$, где ρ — плотность воздуха, θ — местный угол между касательной к профилю и направлением набегающего потока, M — Маха число потока. Коэф. подъёмной силы C_y и сопротивления C_x профили (отнесенные к длине хорды профиля) выражаются формулами

$$C_y = 4\alpha \sqrt{M^2 - 1}, \quad C_x = \left[4\alpha^2 + 2 \left(\bar{\theta}_n^2 + \bar{\theta}_z^2 \right) \right] / \sqrt{M^2 - 1}.$$

Здесь $\bar{\theta}_n$ и $\bar{\theta}_z$ — средние значения по длине профиля квадраты углов наклона элементов верхней и нижней частей контура к его хорде.

Для определения полей скорости и давления при C . т. около тел вращения и профилей немалой толщины, внутри сопел ракетных двигателей и сопел аэродинамич. труб и в др. случаях C . т. пользуются численным методом характеристик и др. численными методами решения уравнений газовой динамики. При использовании быстродействующих вычислит. машин становится возможным расчёт трёхмерных C . т., напр. расчёт обтекания тел вращения под углом атаки, сопел некруглого сечения и др.

Течения с большой сверхзвуковой (гиперзвуковой) скоростью ($v \gg a$) обладают нек-рыми особыми свойствами. Полёт тела в газе с гиперзвуковой скоростью связан с ростом до очень больших значений темп-ры газа вблизи поверхности тела, что вызывается мощным сжатием газа перед головной частью движущегося тела и выделением тепла вследствие внутр. трения в газе, увлекаемом телом при полёте. В связи с этим при изучении гиперзвуковых течений газа необходимо учитывать изменение свойств воздуха при высоких темп-рах, возбуждение внутр. степеней свободы и диссоциацию молекул газов, составляющих воздух, хим. реакции (напр., образование окиси азота), возбуждение электронов и ионизацию. При расчёте равновесных адиабатич. течений газа эти факторы влияют на зависимость теплосодержания газа и его энтропии от темп-ры и давления. В задачах, в к-рых существенны явления молекулярного переноса — при расчёте поверхностного трения, тепловых потоков к обтекаемой газом поверхности и её темп-ры, — необходимо учитывать изменение в широких пределах вязкости и теплопроводности воздуха, в ряде случаев — диффузию и термодиффузию компонент воздуха. Напр., при обтекании охлаждаемой поверхности воздухом высокой темп-ры, содержащим диссоцииров. кислород, у стенки воздух охлаждается и концентрация диссоцииров. частиц кислорода в нём уменьшается. Благодаря этому возникает диффузионный поток атомов кислорода к стенке, рекомбинируя же диффундирующих атомов вблизи стенки связана с выделением тепла. Т. о., действ. тепловой поток к стенке больше того, к-рый был бы найден без учёта диффузии.

В нек-рых условиях гиперзвукового полёта на больших высотах (см. Динамика разреженных газов) процессы, происходящие в газе, нельзя считать термодинамич. равновесными. Установление термодинамич. равновесия в движущейся частице газа происходит не

мгновенно, а требует определ. времени — т. н. времени релаксации, к-рое различно для разл. процессов. Отступления от термодинамич. равновесия могут заметно влиять на процессы, происходящие в пограничном слое (в частности, на величину тепловых потоков от газа к телу), на структуру скачков уплотнения, на распространение слабых возмущений и др. явления. Так, при сжатии воздуха в головной ударной волне легче всего возбуждаются поступат. степени свободы молекул, определяющие темп-ру воздуха, и его излучение в области за ударной волной может быть намного выше, чем по расчёту в предположении о мгновенном возбуждении колебат. степеней свободы.

При очень высокой темп-ре (~3000—4000 К и более) в воздухе присутствуют в достаточно большом количестве ионы, частицы и свободные электроны. Хорошая электропроводность воздуха вблизи тела открывает возможность использования эл.-магн. воздействий на поток для изменения сопротивления тела или уменьшения тепловых потоков от горячего газа к телу. Она же затрудняет проблему радиосвязи с летат. аппаратом из-за отражения и поглощения радиоволн ионов, газом, окружающим тело. Нагревание воздуха при сжатии его перед головной частью движущегося с гиперзвуковой скоростью тела может вызывать мощные потоки лучистой энергии, частично передающейся телу и вызывающей дополнит. трудности при решении проблемы его охлаждения. Рациональным выбором формы тела можно добиться значит. степени рассеивания лучистой энергии в окружающих слоях воздуха.

Если скорость набегающего потока во много раз превосходит скорость звука, то при малых возмущениях скорости изменения давления и плотности уже не будут малы и необходимо пользоваться нелинейными уравнениями даже при изучении обтекания тонких заостренных тел. Сущность, роль нелинейных эффектов характерна для гиперзвуковой аэродинамич. Мн. представления аэродинамич. умеренных сверхзвуковых скоростей, касающиеся поведения сил и моментов, действующих на летат. аппараты, а также устойчивости и управляемости этих аппаратов, становятся неприменимыми при гиперзвуковых скоростях полёта.

Большие значения числа M в течениях с гиперзвуковой скоростью позволяют установить важные качественные особенности таких течений и развивать нелинейные асимптотич. теории для их количеств. анализа. Для приближённого определения давления на головную часть затупленных шпандель тел вращения и профилей подучала распространение ф-лы Ньютона, согласно к-рой избыточное давление Δp на элемент поверхности тела равно нормальной к этому элементу составляющей кол-на движения набегающего потока, т. е. $\Delta p = \rho v^2 \sin^2 \theta$, где θ — угол между направлением набегающего т. о. на поверхности тела и направлением набегающего потока.

Лит.: Давыдов А. Л. Д., Лифшиц Е. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика, 5 изд., ч. 1—2, М., 1981; Черный Г. Р., Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью, М., 1959; его же, Газовая динамика, М., 1988; Зеленова И. В., Вальдер Ю. П., Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений, 2 изд., М., 1966; Овсяняков И. В., Лекция по основам газовой динамики, М., 1961, г. 1, гл. 1.

СВЕРХИЗЛУЧЕНИЕ — коллективное спонтанное испускание эл.-магн. излучения при переходе системы N возбуждённых излучателей ($N > 1$) в когерентное сфазированное состояние. С. предсказано Р. Г. Дикке (R. H. Dicke) в 1954, обнаружено экспериментально в 1973 после создания лазеров.

Дикке показал, что система N инвертированных двухуровневых атомов (см. Двухуровневая система) может спонтанно перейти в осн. состояние за время, обратно пропорциональное числу атомов $\tau \sim 1/N$. Этот эффект обусловлен наведением корреляций между дипольными моментами перехода пространственно разделённых излучателей, взаимодействующих друг с

другом через поле излучения. В результате атомы, находящиеся в макроскопически большом объёме, излучают когерентно. Поскольку полная энергия, излучаемая коллективным атомом, равна $N\hbar\omega_0$ (ω_0 — частота перехода), то интенсивность излучения $I \propto N\hbar\omega_0^2 \tau \propto N^2$. В случае же обычного спонтанного излучения, когда атомы распадаются независимо друг от друга со временем спонтанного распада T_1 , не зависящим от числа излучателей, интенсивность $I \propto N\hbar\omega_0^2 \tau \propto N$.

С ансамбля излучателей обуславливается воздействием поля, испущенного одним из осцилляторов, на все остальные излучатели ансамбля. Именно это воздействие способно привести к когерентизации процесса испускания излучения ансамблем осцилляторов. Эфф. самонаведение корреляций между дипольными моментами осцилляторов возможно лишь в том случае, когда время этого процесса t_0 меньше времени релаксации дипольного момента атома T_2 , а также меньше T_1 (обычно $T_2 < T_1$). Таким образом, С. представляет собой нестационарный процесс, протекающий за время, меньше T_1 и T_2 . Установление корреляций между излучателями происходит самопроизвольно в процессе излучения, этим С. отличается принципиально от нестационарных когерентных процессов, обусловленных внеш. когерентной накачкой, таких, как самоиндуцированная прозрачность, фотонное эхо и др.

По характеристикам и условиям наблюдения С. отличается и от обычного спонтанного излучения, и от стимулированного излучения. Это отличие можно рассмотреть на примере типичного эксперимента по наблюдению С. (рис. 1, б). Внутри макроскопически большого, вытянутого и открытого с обеих концов цилиндра длиной L и площадью основания S ($L \gg \sqrt{S}$, $V = LS$,

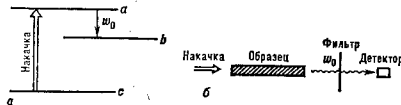


Рис. 1. Схема рабочих уровней (а) и экспериментальной установки (б) в типичном эксперименте по наблюдению сверхизлучения.

$\lambda = N/V$) находится N двухуровневых атомов. Сначала атомы переводятся в верх. состояние (рис. 1, а) достаточн. коротким ($t_{\text{н}} < T_1$) импульсом накачки так, чтобы состояние системы было некогерентным (т. е. корреляции между дипольными моментами отсутствуют). Затем начинается свободный распад системы инвертиров. атомов, характер к-рого зависит от соотношения вре-

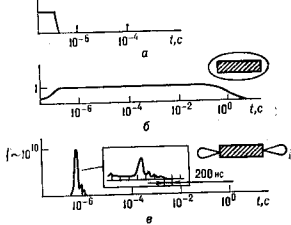


Рис. 2. Сравнение сверхизлучения и некогерентного спонтанного распада: а — импульс накачки, инвертирующий рабочий период; б — интенсивность излучения в случае некогерентного спонтанного распада ($T_1 \sim 1$ с); в — наблюдаемый остронаправленный сигнал сверхизлучения (газ НФ), пиковая интенсивность сигнала сверхизлучения примерно в 10^{10} раз превосходит интенсивность спонтанного распада.

менных параметров: T_1 , T_2 , $t_{\text{н}}$, а также $\tau = L/c$ — времени полёта фотона через среду. Если плотность атомов настолько мала, что $T_1 < t_{\text{н}}$, то каждый атом распадается независимо от других и система излучает спонтанно и изотропно по всем направлениям с характерным временем T_1 (рис. 2, б).

Если же выполняется условие

$$\tau < t_{\text{н}} < T_2, T_1,$$

то наблюдается С. Правое неравенство означает, что коллективные процессы протекают быстрее, чем релаксационные процессы в каждом атоме. Левое неравенство означает, что фотоны нежатко объём за время, меньше времени наведения межатомных корреляций, так что стимулированные процессы во время развития С. можно пренебречь. При выполнении этих условий система N атомов излучает импульс S , пиковая интенсивность к-рого на век. порядков превосходит интенсивность спонтанного излучения, причём осн. часть излучения направлена вдоль набв. вытянутости объёма (рис. 2, в). При $t_{\text{н}} \sim t_{\text{н}}$ часть излучённой энергии снова запычивается в атомную подсистему и излучение формируется в виде последовательности импульсов с уменьшающимися амплитудами (рис. 2, в) — осцилляторный режим S_1 .

Важной характеристикой С. является время задержки импульса t_0 , определяемое по моменту наблюдения максимумов импульса, к-рое примерно на порядок превосходит длительность самого импульса — С. ($t_0 \sim t_{\text{н}}/N$). Такая задержка импульса С. объясняется тем, что процесс распада начинается с начального спонтанного излучения, и лишь благодаря взаимодействию атомов через поле излучения в системе происходит нарастание корреляций дипольных моментов атомов, к-рые достигают макс. значения как раз в момент t_0 .

В случае $T_2 < t_{\text{н}} \ll \tau$ наблюдается режим усиления спонтанного излучения. Левое неравенство означает, что поляризация быстро подстраивается под поле, а правое — то, что фотоны остаются внутри среды на время τ , достаточное для лавинообразного нарастания стимулир. излучения (протекающего за время $t_{\text{н}}$). В литературе процесс усиления спонтанного излучения наз. также часто *сверхамплицесцил.* С. отличается от него тем, что в формировании С. вынужденные переходы атомов практически не играют роли.

Эффект С. имеет как общефиз., так и прикладное значение. С физ. точки зрения эффект С. является примером кооперативного поведения системы N частиц, взаимодействующих с ал.-магн. полем. Вопросы о формировании скоррелиров. состояний в такой системе, выяснение роли геометрии среды в формировании пространственной когерентности и влияния формы на скорость указанных процессов представляют общий интерес. С прикладной точки зрения эффект С. имеет значение как один из методов получения когерентного излучения в беззеркальных системах. Особенно это важно для ИВ-диапазона (рентгеновского и гамма-излучения), где трудно надеяться на получение высокоотражающих зеркал. Теоретич. оценки показывают, что С. может оказаться возможным механизмом генерации когерентного излучения в оптич. диапазонах.

Лит.: 1) D. S. K. и R. H. Coherent In spontaneous radiation processes, «Phys. Rev.», 1954, т. 93, р. 99; 2) А. Н. Дрессев, А. В. Оптическое сверхизлучение: новые идеи и новые эксперименты, «УФН», 1990, т. 160, в. 12, с. 1; 3) А. Н. Дрессев, А. В. Емельянов и В. И. Козырев и Ю. А. Кооперативные явления в оптич. сверхизлучении. Выстабильность. Фазовые переходы, М., 1988; 4) Кооперативное излучение и статистика фотонов, Л., 1986.

А. В. Андреев
СВЕРХИИЖЕКЦИЯ — явление, возникающее при инжекции носовосновных носителей заряда в *германиеподобные* полупроводники в превышении концентрации носовосновных носителей в материале, в к-рый происходит инжекция, по сравнению с концентрацией носителей в эммит-

ре. С. электронов может наблюдаться при инжекции из материала с меньшим средством к электрону в материале с большим средством. Механизм С. иллюстрируется зонной картиной $p-n$ -перехода в системе GaAs — GaAlAs. На рис. 1 (а) изображена зонная схема гетероперехода p -GaAs — n -GaAlAs в состоянии равновесия, на рис. 1 (б) — при приложении напряже-

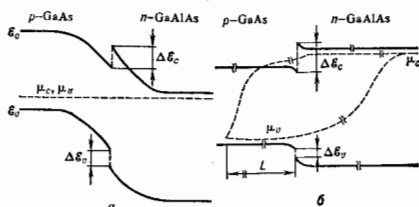


Рис. 1. Зонная схема гетероперехода p -GaAs, n -GaAlAs: а — в состоянии равновесия; б — при приложении напряжения в прямом направлении.

ния в пропускном направлении. Изображены линии, отвечающие положению краёв зон (E_c и E_v) и положению квазиуровней Ферми (μ_c и μ_v); ΔE_c и ΔE_v — разрывы зон. Условия квазиравновесия отвечают постоянству квазиуровней Ферми в слое пространственного заряда, поэтому если условия квазиравновесия выполняются, то концентрация электронов в узкозонном GaAs оказывается больше, чем в эмиттере на GaAlAs. Для невырожденных носителей заряда макс. величина коэф. С. χ (отношение концентрации инжектиров. носителей к их концентрации в эмиттере) может быть оценена как $\exp(\Delta E_c/kT)$. В рамках диффузионной теории макс. значение χ с учётом падения квазиуровней Ферми равно отношению диффузионной длины и длины Дебая L/d . При инжекции в двойной гетероструктуре, в k -рой тонкий слой узкозонного материала заключён между широкозонными эмиттерами (рис. 2), в выражении для максимального χ появляется дополнит.

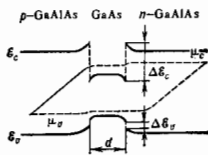


Рис. 2. Двойная гетероструктура в режиме сверхлюминесценции.

множитель L/d , где d — толщина узкозонного слоя, в k -ром происходит рекомбинация. С. может наблюдаться и в плавных гетеропереходах, в k -рых параметры материала непрерывно изменяются с координатой. Гетеропереход может считаться резким, если изменение таких параметров, как ширина запрещённой зоны, средство к электрону на величину порядка kT , происходит на расстояниях, меньших длины Дебая, в противном случае в выражении для χ дебаевская длина заменяется на характерную полевую длину, совпадающую с расстоянием, на k -ром ширина запрещённой зоны меняется на величину kT . Поскольку, как правило, дебаевская длина много меньше диффузионной длины, величина χ может достигать в реальных гетеропереходах, как плавных, так и резких, весьма больших значений. С. широко используется в гетеротранзисторах и гетеролазерах. В гетеротранзисторах за счёт С. обеспечивается односторонняя инжекция носителей в базу. В гетеролазерах С. позволяет ис-

пользовать в качестве эмиттеров относительно слабо легированные слои с низкими оптич. потерями, что способствует снижению порогового тока гетеролазера и повышению дифференц. квазатовой эффективности.

Лит.: А л ф е р о в Ж. И., К а з а р и н о в Р. Ф., Х а л ф и н И. С. Об одной особенности инжекции в гетероструктурах «ФТТ», 1966, т. 8, № 10, с. 3102; А л ф е р о в Ж. И. и др., Инжекционные свойства гетеропереходов n -Al_{0.3}Ga_{0.7}As — p -GaAs, «ФТТ», 1968, т. 2, в. 7, с. 1016; К а з а р и н о в Р. Ф., О предельном снижении пороговой плотности тока инжекционных лазеров с двойной гетероструктурой, «ФТН», 1973, в. 4, с. 763; К а з а р и н о в Р. Ф., С у р и с Р. А., Свершинамские посетители в вариазонных p -структурах, «ФТН», 1975, т. 9, в. 1, с. 12; Б е л и с с е в П. П., Изменения в физике инжекционных лазеров, М., 1983; К о г о л ь к о в В. И., Electric and photoelectric properties of heterostructures, в кн.: Semiconductor heterostructures. Physical processes and applications, Moscow, 1989, в. 5, с. 15—17.

СВЕРХЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (суперлюминесценция) — излучение активной среды, в k -рой создана инверсия населённости уровней энергии без обратной связи. С. наблюдается в активной среде лазера до достижения порога генерации или в направлении, для k -рых усиление на проход меньше потерь. С. отличается от люминесценции суженным спектром и диаграммой направленности, имеющей максимум в направлении макс. длин пути в усиливающей среде; от лазерного излучения — отсутствием модовой структуры, меньшей направленности и более широким спектром. Явление С. играет вредную роль в многокаскадных лазерных усилителях, т. к. снижает степень инверсии населённости. Для уменьшения С. между каскадами применяют оптич. развязки. В безрезонансных однопорядковых лазерах с большим коэф. усиления, имеющих длину, много большую поперечных размеров активной среды, С. выступает в качестве лазерного излучения. Схемы таких лазеров обсуждаются как один из возможных путей осуществления релаксационных и гамма-лазеров.

СВЕРХНИЗКОЧАСТОТНЫЕ РАДИОВОЛНЫ — электромагнитные волны, диапазон частот k -рых по сравнению с радиолучем радиосвязи охватывает область от 30 до 300 Гц (длина волн от 10 до 1 Мв). Распространение радиоволн сверхнизкочастотного (СНЧ) диапазона происходит в волноводном канале, ограниченном поверхностью Земли и ниж. кромкой ионосферы, высота k -рой в зависимости от времени суток и геоиз. условий изменяется от 60 до 90 км. Поскольку длина волны значительно превышает высоту канала, в волноводе Земля — ионосфера распространяется только квази-ТЕМ-волна (см. Волновой жемальский). Она имеет 2 осн. составляющие: радиальную (вертикальную) электр. поля и азимутальную (горизонтальную) магн. поля. Благодаря одностороннему распространению передаваемые сигналы в СНЧ-диапазоне отличаются высокой стабильностью. Затухание СНЧ-радиоволн в волноводе Земля — ионосфера малое и с ростом частоты изменяется от долей дБ/1000 км до единиц дБ/1000 км. Благодаря этому возможна передача радиосигналов на очень большие расстояния, вплоть до кругосветных трасс. При этом напряжённость поля, осциллируя за счёт интерференции волн, заметно возрастает по мере приближения к антиподной точке.

Интерференция кругосветных СНЧ-волн проявляет себя в т. в. пумановетских резонансах, при k -рых на совств. частотах резонатора Земля — ионосфера наблюдается увеличение атм. шумов.

Влияние магн. поля Земли приводит к зависимости фазовой скорости СНЧ-радиоволн и их затухания от направления распространения.

СНЧ-диапазон характеризуется высоким уровнем радиопомех. Естеств. помехи порождают электр. разряды в атмосфере, а искусственные — работой промышленных электроустановок и линиями электропередач. Кроме того, темп. передачи информации из-за узости диапазона оказывается очень низким. Тем не менее большая глубина скин-слоя является столь важ-

С. з. II типа (SN1987A), вспыхнувшая в 1987 в БМО, имеет необычайно высокую светимость: в максимуме блеска она величина в полосе B всего $\approx -14,5^m$. В то же время на квазиаксионе, участке она не отличается от других С. з. II типа и её блеск уменьшается с темпом ок. $0,0078^m$ в сутки. Энергия ад.-магн. излучения (от дальней ИК- до дальней УФ-области спектра), испускаемая за всё время, $\approx 8 \cdot 10^{48}$ эрг. Близость БМО, находящегося на расстоянии примерно 52 кпк, позволила выполнить уникальные наблюдения. Впервые стали известны свойства звезды накануне вспышки С. з. Установлено, что взорвалась звезда-сверхгигант спектрального класса $B3Ia$ с массой $15-25 M_{\odot}$ и радиусом примерно $50 R_{\odot}$. Именно размеры звезды, малые по сравнению с размерами звёзд, вспыхивающих как С. з. II типа, объясняют необычные свойства кривой блеска SN1987A (рис. 3). Впервые нейтринные телескопы зарегистрировали сигнал от вспышки С. з. Нейтринная вспышка была зафиксирована примерно за 3 ч до первого наблюдения оптич. вспышки и обладает след. характеристиками: ср. энергия детектируемых электронов антинейтрино $20-30$ МэВ; предположит. длительность нейтринного сигнала ок. 10 с; полная энергия, унесённая нейтрино из звезды, $\approx 3 \cdot 10^{53}$ эрг. Нейтринная вспышка является непосредств. свидетельством гравитат. коллапса центр. ядра взорвавшейся звезды. Впервые на стадии квазиаксионе, падения блеска зарегистрирована гамма-линия 847 кэВ, K -рая возникает при распаде радиоакт. изотопа кобальта (^{60}Co) в железо. Характерное время квазиаксионе. спадания блеска $111,3$ сут, что практически совпадает со временем распада ^{60}Co . Все эти факты свидетельствуют о том, что в максимуме блеска и после него осн. источником энергии эл.-магн. излучения является распад ^{60}Co .

Конечные стадии эволюции звёзд и вспышки сверхновых звёзд. Вспышка С. з. является результатом динамич. эволюции ядра звезды, K -рая начинается с момента нарушения гидростатич. равновесия в звезде, уже далеко продвинувшейся в своей эволюции. Динамич. эволюция ядра завершается либо полным разлётом вещества звезды, либо *гравитационным коллапсом* ядра. Характер эволюции в осн. определяется массой звезды.

Поздние стадии эволюции звезды начинаются с термоядерного горения гелия в её центр. области, что на Герцшпрунга — Рассела диаграмме соответствует переходу звезды с гл. последовательности в область красных или голубых гигантов. В процессе эволюции центр. область звезды становится всё плотнее и горячее, а её оболочка, наоборот, расширяется и охлаждается. При этом возрастает и становится определяющими потери энергии за счёт нейтринного излучения (нейтрино образуются гл. обр. при аннигиляции электрон-позитронных пар). После завершения гелиевого горения в центре звезды образуется углеродно-кислородное ядро (С-О-ядро), причём его масса тем больше, чем больше масса звезды на гл. последовательности. В С-О-ядре с достаточно малой массой давление полностью определяется вырожденным газом электронов. Вырожденное С-О-ядро может иметь массу вплоть до *Чандрасекара предела*, т. е. до верх. предела массы вырожденной звезды, ещё находящейся в гидростатич. равновесии. Для С-О-ядра предел Чандрасекара равен $1,44 M_{\odot}$, и ядро с массой, превышающей это значение, является невзорженным. Дальнейшая эволюция звезды происходит по-разному для вырожденного и невзорженного С-О-ядра.

Сначала в вырожденном С-О-ядре термоядерные реакции с участием углерода практически не протекают, поскольку существует интенсивное охлаждение ядра нейтринным излучением (нейтрино уносят энергию из ядра). Выделение энергии в звезде на этой стадии эволюции происходит в осн. за счёт слоевых источников энергии (фронтов термоядерного синтеза He, C и O),

самый внутренний из K -рых (синтез C и O из He) расположен на границе вырожденного ядра. Масса С-О-ядра постепенно увеличивается благодаря поступлению в него продуктов горения из слоевого источника. По мере увеличения массы в С-О-ядре возрастает плотность и темп-ра. Приближение массы С-О-ядра к пределу Чандрасекара сопровождается реакцией увеличения плотности в центре ядра, что приводит к сильному релятивистскому вырождению электронного газа. Такой рост вырожденного ядра характерен для эволюции звезды с массой $4-8 M_{\odot}$ на гл. последовательности. В конце концов в ядре создаются условия для «зажигания» углерода. Поскольку повышение темп-ры в сильно вырожденном веществе практически не приводит к увеличению давления, то горение углерода развивается при пост. плотности и приобретает взрывной характер: нарушается гидростатическое равновесие режим горения, происходит термоядерный взрыв С-О-ядра звезды. В процессе углеродного горения темп-ра сильно повышается и вслед за основной ядерной реакцией синтеза магния осуществляется цепочка ядерных реакций, ведущих к образованию элементов вплоть до элементов «железного пика» (железо, никель и др.) на кривой *распространённости элементов*, в т. ч. радиоактивного изотопа никеля (см. *Нуклеосинтез*). Последний играет важную роль в формировании кривых блеска С. з. Термоядерный взрыв вырожденного С-О-ядра приводит к частичному или полному сгоранию углерода. При этом происходит полный разлёт С-О-ядра с кинетич. энергией разлетающегося вещества $10^{50}-10^{51}$ эрг. Таков, по-видимому, механизм вспышки С. з. I типа.

Невырожденное С-О-ядро образуется в звезде, имеющей на гл. последовательности массу больше $10 M_{\odot}$. В этом случае дальнейшая ядерная эволюция центр. областей звезды проходит через стадии термоядерного горения углерода, неона, кислорода, кремния и завершается образованием элементов «железного пика». После исчерпания запасов ядерного топлива звезда интенсивно теряет энергию посредством нейтринного излучения. Потери энергии приводят к дальнейшему сжатию звезды и нагреву вещества, т. к. электронный газ внутри достаточно массивных железных ядер звёзд фактически не вырожден. Увеличение темп-ры и плотности, в конце концов, вызывает распад ядер элементов «железного пика» на нейтроны и ядра гелия, K -рые, в свою очередь, распадаются на нейтроны и протоны. Процесс распада ядер железа требует столь значит. затрат энергии тепловому движению на преодоления энергии связи атомных ядер, что с увеличением плотности вещества резко замедляется рост давления. К дополнительному эффекту ведут также процессы рождения электрон-позитронных пар и процессы захвата электронов ядрами элементов «железного пика». В результате нарушается гидростатич. равновесие — силы давления не могут противостоять силам тяготения, и начинается гравитат. коллапс железного ядра звезды. При массе железного ядра не более $\approx 2 M_{\odot}$ (т. е. меньше предельной массы холодной нейтринной звезды) гравитат. коллапс в нек-рый момент останавливается. Образуется горячая *нейтринная звезда* охлаждается за счёт излучения нейтрино с её поверхности и за характерное время ~ 10 с превращается в холодную нейтринную звезду. Такой гравитат. коллапс может быть обнаружен по мощному импульсу нейтринного излучения, что и произошло в случае SN1987A. При массе железного ядра больше предельной ($> 2 M_{\odot}$) гравитат. коллапс продолжается неограниченно и переходит в релятивистскую стадию с образованием *чёрной дырки*.

Интерпретация вспышек сверхновых звёзд. Взрывное выделение энергии, K -рое сопровождается феноменом вспышки С. з., приводит к формированию сильной ударной волны, распространяющейся к поверхности звезды. При прохождении ударной волны внутр. зер-

гия вещества увеличивается и оно приобретает большие скорости расширения. Распирение выброшенного вещества сопровождается адiabатич. охлаждением и, следовательно, уменьшением внутр. энергии. Адиабатич. охлаждение определяется гл. обр. радиусом звезды каканауче испышки: чем больше радиус, тем меньше адиабатич. потери внутр. энергии и выше светимость С. з. Поэтому наблюдаемые светимости С. з. могут быть получены при нач. радиусах, сопоставимых с радиусом фотосферы в максимуме блеска ($\sim 10R_{\odot}$). Для значительно меньших нач. радиусов необходимо предположить существование доп. источника энергии, к-рый в процессе расширения вещества непрерывно компенсирует адиабатич. потери. Таким источником энергии является распад радиоакт. изотопа никеля в кобальт и далее в железо. Каждый распад сопровождается получением нек. гамма-квантов с энергией ~ 1 МэВ, к-рая преобразуется в тепловую энергию при их взаимодействии с веществом.

Звёзды, вспыхивающие как С. з. I типа, в ходе эволюции потеряли богатые водородом слои и имеют радиусы ($\sim 0,01R_{\odot}$), значительно уступающие радиусу фотосферы в максимуме блеска. Поэтому кривые блеска С. з. I типа полностью определяются радиоакт. источником энергии. Необходимое кол-во радиоакт. изотопа никеля $\approx 0,4-1 M_{\odot}$. Такое кол-во изотопа никеля может образоваться в результате взрыва вырожденного С-0-ядра, отвечающего вспышке С. з. I типа.

С. з. II типа (за исключением подобных SN1987A) являются результатом взрыва звёзд с радиусом ок. $5 \cdot 10^8 R_{\odot}$. Их кривые блеска до квазиэкспонен. стадии объясняются высвечиванием внутр. энергии, запасённой при взрыве. Масса выброшенного вещества С. з. II типа ок. $5M_{\odot}$. III типа — существенно меньше. Уникальные свойства кривой блеска SN1987A (рис. 3) — прямое следствие относительно малого нач. радиуса звезды ($30-60 R_{\odot}$), к-рому соответствуют большие адиабатич. потери и меньшая светимость (по сравнению с другими С. з. II типа). Вблизи максимума блеска и на квазиэкспонен. стадии оптич. светимость SN1987A обеспечивается радиоакт. источником энергии. По-видимому, и в других С. з. II типа на квазиэкспонен. стадии радиоакт. источник энергии принадлежит доминирующая роль. Вспышки С. з. II типа, вероятнее всего, происходят при взрывах, индифферентных гравитат. коллапсом невырожденных ядер звёзд.

Лит.: Шкловский И. С., Сверхновые звёзды, 2 изд., М., 1976; Ивс и с-е в кн. В. С. Найденов и Д. К. Кочневские главы эволюции звёзд и вспышки сверхновых, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Астрономия, т. 21, М., 1982; иж же, Сверхновые 1987 в Большом Магеллановом Облаке: наблюдения и теория, УФН, 1988, т. 156, в. 4, с. 561; W o o l e y e y S. E., Ч у а н г Т. А., The physics of supernova explosions, «Adv. Phys. Astron. Astroph.», 1988, в. 24, р. 205; В д и н я н о в С. И., Д о з а н с к а я Т. А., Ч у г а й Н. Н., Сверхновые звёзды и вспышки сверхновых, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Астрономия, т. 32, М., 1987.

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ — явление, заключающееся в том, что у мн. хим. элементов, соединений, сплавов (взв. сверхпроводниками) при охлаждении ниже опред. (характерной для данного материала) темп-ры T_c наблюдается переход из нормального в т. я. сверхпроводящее состояние, в к-ром их электрич. сопротивление пост. току полностью отсутствует. При этом переходе структуры мн. и оптич. (в области видимого света) свойства сверхпроводников остаются практически неизменными. Электрич. и магн. свойства вещества в сверхпроводящем состоянии (фазе) резко отличаются от этих же свойств в нормальном состоянии (где они, как правило, являются металлами) или от свойств др. материалов, к-рые при тех же темп-рах в сверхпроводящее состояние не переходят.

Явление С. открыто Г. Камерлинг-Оннесом (Н. Камерлинг-Onnes, 1911) при исследовании низкотемпературного хода сопротивления ртути. Он обнаружил,

что при охлаждении ртутной проволоки ниже 4 К её сопротивление скачком обращается в нуль. Нормальное состояние может быть восстановлено при пропускании через образец достаточно сильного тока [превышающего критический ток $I_c(T)$] или помещением его в достаточно сильное внеш. магн. поле [превышающее критическое магнитное поле $H_c(T)$].

В 1933 Ф. В. Мейснером (F. W. Meißner) и Р. Оксенфельдом (R. Ochsenfeld) обнаружено др. важнейшее свойство, характерное для сверхпроводников (см. Мейснера эффект): внеш. магн. поле, меньшее нек-рого критич. значения (зависящего от типа вещества), не проникает в глубь сверхпроводника, имеющего форму бесконечного сплошного цилиндра, ось к-рого направлена вдоль поля, и отлочно от нуля лишь в тонком поверхностном слое. Это открытие позволило Ф. и Г. Лондонам (F. London, H. London, 1935) сформулировать феноменологич. теорию, описывающую магнитостатич. сверхпроводников (см. Лондонов уравнение), однако природа С. оставалась неясной.

Открытие в 1938 сверхтекучести и объяснение этого явления Л. Д. Ландау на основе сформулированного им критерия (см. Ландау теория сверхтекучести) для систем бозе-частиц давали основание предполагать, что С. можно трактовать как сверхтекучесть электронной жидкости, однако фермиевская природа электронов и кулоновское отталкивание между ними не позволили просто перенести теорию сверхтекучести на С. В 1950 В. Л. Гинзбург и Ландау на основе теории фазовых переходов 2-го рода (см. Ландау теория) сформулировали феноменологич. ур-ния, описывающие термодинамику и эл.-магн. свойства сверхпроводников вблизи критич. темп-ры T_c . Построение микроскопич. теории (см. ниже) обосновало Гинзбурга — Ландау теорию и уточнило входящие в феноменологич. ур-ния постоянные. Открытие зависимости критич. темп-ры T_c перехода в сверхпроводящее состояние металла от его изотопного состава (изотопический эффект, 1950) свидетельствовало о влиянии кристаллич. решётки на С. Это позволило Х. Фрöhлиху (H. Fröhlich) и Дж. Бардину (J. Bardeen) продемонстрировать возможность возникновения между электронами в присутствии кристаллич. решётки специфического притяжения, к-рое может преваллировать над их кулоновским отталкиванием, а впоследствии Л. Куперу (L. Cooper, 1956) — возможность образования электронами связанных состояний — куперовских пар (Куперов эффект).

В 1957 Дж. Бардином, Л. Купером и Дж. Шриффером (J. Schrieffer) была сформулирована микроскопич. теория С, к-рая объяснила это явление на основе бозеконденсации куперовских пар электронов, а также позволила в рамках простой модели (см. Бардина — Куперов — Шриффера модель, модель БКШ) описать м. свойства сверхпроводников.

Практич. использование сверхпроводников ограничивается низкими значениями критич. полей (~ 1 кэ) и темп-р (~ 20 К). В 1952 А. А. Абрикосов и Н. Н. Зваричский на основании анализа эксперим. данных о критич. магн. полях тонких сверхпроводящих плёнок указали на возможность существования нового класса сверхпроводников (с их необычными магн. свойствами ещё в 1937 столкнулся Л. В. Шубников, одним из важнейших отличий от обычных сверхпроводников является возможность протекания сверхпроводящего тока при неполном вытеснении магн. поля из объёма сверхпроводника в широком диапазоне магн. полей). Это открытие определило в дальнейшем разделение сверхпроводников на сверхпроводники первого рода и сверхпроводники второго рода. Использование сверхпроводников 2-го рода впоследствии позволило создать сверхпроводящие системы с высокими критич. полями (порядка сотен кэ).

Поиск сверхпроводников с высокими критич. темп-рами стимулировал исследование новых типов материалов. Были исследованы мн. классы сверхпроводящих

систем, синтезированных органические сверхпроводники и мажоритные сверхпроводники, однако до 1986 макс. критич. темп-ра наблюдалась у силана Nb_3Ge ($T_c \approx 23$ К). В 1986 И. Г. Бедворцем (J. G. Bednorz) и К. А. Мюллером (K. A. Müller) был открыт новый класс металлоксидных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) (см. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*), критич. темп-ра к-рых в течение двух последующих лет была «поднята» от 30–35 К до 120–125 К. Эти сверхпроводники интенсивно изучаются, ведутся поиски новых, улучшаются технол. свойства существующих, на основе к-рых уже создаются нек-рые приборы.

Важным достижением в области С. стало открытие в 1962 Джозефсона эффекта тунелирования куперовских пар между двумя сверхпроводниками через тонкую диэлектрич. прослойку. Это явление легло в основу новой области применений сверхпроводников (см. *Слабая сверхпроводимость, Криоэлектронные приборы*).

Природа сверхпроводимости. Явление С. обусловлено возникновением корреляции между электронами, в результате к-рой они образуют куперовские пары, подчиняющиеся бозеовской статистике, а электронная жидкость приобретает свойство сверхтекучести. В фоновой модели С. спаривание электронов происходит в результате специфического, связанного с наличием кристаллич. решётки фононного притяжения. Даже при абс. нуле темп-ры решётка совершает колебания (см. *Нулевые колебания, Динамика кристаллической решётки*). Эл.-статич. взаимодействие электрона с ионами решётки изменяет характер этих колебаний, что приводит к появлению дополнит. силы притяжения, действующей на др. электроны. Это притяжение можно рассматривать как обмен виртуальными фононами между электронами. Такое притяжение связывает электроны в узком слое вблизи границы ферми-поверхности. Толщина этого слоя в энергетич. масштабе определяется макс. энергией фонона $\hbar\omega_D \sim \hbar v_s/a$, где ω_D — дебаевская частота, v_s — скорость звука, a — постоянная решётки (см. *Дебая температура*); в импульсном пространстве это соответствует слою толщиной $\Delta p \sim \hbar\omega_D/v_F$, где v_F — скорость электронов вблизи поверхности Ферми. Соотношение неопределённостей даёт характерный масштаб области фононного взаимодействия в координатном пространстве:

$$\Delta r \sim \hbar/\Delta p \sim v_F/\omega_D \sim v_F a/v_s \sim (M/m)^{1/2} a,$$

где M — масса иона остова, m — масса электрона. Величина $\Delta r \sim 10^{-6} \div 10^{-5}$ см, т. е. фононное притяжение оказывается дальнедействующим (по сравнению с межатомами расстояниями). Кулоновское отталкивание электронов обычно несколько превышает по величине фононное притяжение, но благодаря экранированию на межатоми расстояниях оно эффективно ослабляется и фононное притяжение может преобладать, объединяя электроны в пары. Сравнительно небольшая энергия связи куперовской пары оказывается существенно меньше кинетической энергии электронов, поэтому, согласно квантовой механике, связанные состояния не должны были бы возникнуть. Однако в данном случае речь идёт об образовании пар не из свободных изолиров. электронов в трёхмерном пространстве, а из квазиэлектрон ферми-жидкости при заполненной большой поверхности Ферми. Это приводит к фактич. замене трёхмерной задачи на одномерную, где связанные состояния возникают при сколь угодно слабом притяжении.

В модели БКШ спариваются электроны с противоположными импульсами p и $-p$ (полный импульс куперовской пары равен 0). Орбитальный момент и суммарный спин пары также равны 0. Теоретически при нек-рых фононных механизмах С. возможно спаривание электронов и с ненулевым орбитальным моментом. По-видимому, спаривание в такое состояние осу-

ществляется в сверхпроводниках с тяжёлыми фермионами (напр., $CeCu_2Si_3$, $CeCu_3$, UB_3 , $CeAl_3$).

В сверхпроводнике при темп-ре $T < T_c$ часть электронов, объединённых в куперовские пары, образует бозе-конденсат (см. *Бозе — Эйнштейна конденсация*). Все электроны, находящиеся в бозе-конденсате, описываются единой когерентной волновой ф-цией Ψ . Исклонные электроны пребывают в возбуждённых неконденсатных состояниях (фермионские квазиэлектрон), причём их энергетич. спектр перестраивается по сравнению со спектром электронов в нормальном металле. В изотропной модели БКШ зависимость энергии электронов ϵ от импульса p в сверхпроводнике имеет вид (p_F — ферми-импульс):

$$\epsilon(p) = \sqrt{\Delta^2 + v_F^2 (p - p_F)^2}$$

Т. о., вблизи уровня Ферми (рис. 1) в спектре возникает энергетическая щель Δ . Дад

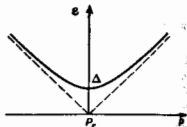


Рис. 1. Перестройка энергетического спектра электронов в сверхпроводнике (сплошная линия) по сравнению с нормальным металлом (пунктир).

то чтобы возбудить электронную систему с таким спектром, необходимо разорвать хотя бы одну куперовскую пару. Поскольку при этом образуются два электрона, то на каждый из них приходится энергия не меньшая Δ , так что 2Δ имеет смысл энергии связи куперовской пары. Величина щели существенно зави-

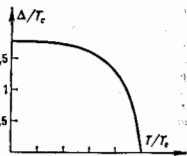


Рис. 2. Температурная зависимость энергетической щели в модели БКШ.

сит от темп-ры (рис. 2), при $T_c - T \ll T_c$ она ведёт себя как $\Delta(0)/k = 3,06V/T_c(T_c - T)$, а при $T = 0$ достигает макс. значения $\Delta(0)/k \approx 1,76T_c$, причём

$$\Delta(0) = \hbar\omega_D \exp(-2/\rho g), \quad (2)$$

где $\rho = m^2 p_F^2 / 2\pi^2 \hbar^3$ — плотность однопольных состояний вблизи поверхности Ферми, g — зфф. константа межэлектронного притяжения.

В модели БКШ связь между электронами предполагается слабой ($\rho g \ll 1$) и критич. темп-ра оказывается малой по сравнению с характерными фононными частотами ($kT_c \ll \hbar\omega_D$). Однако для ряда веществ (напр., Pb) это условие не выполняется и параметр $\rho g \sim 1$ (сильная связь). В литературе обсуждается даже приближение $\rho g \gg 1$. Сверхпроводники с сильной связью между электронами описываются т. н. уравнениями и Элиашберга (Г. М. Элиашберг, 1968), на к-рых видно, что на величину T_c не возникает никаких принципиальных ограничений.

Наличие щели в спектре электронов приводит к экспоненц. зависимости $[\sim \exp(-\Delta(0)/kT)]$ в области высоких темп-р всех величин, определяющихся числом этих электронов (напр. электронной теплоёмкости и теплопроводности, коэффициентов поглощения звука и низкочастотного $[\hbar\omega \ll \Delta(0)]$ эл.-магн. излучения).

Вдоль от ферми-уровня ($v_F |p - p_F| \gg \Delta$) выражение (1) описывает энергетич. спектр электронов нормаль-

ного металла, т. е. эффект спаривания оказывает влияние на электроны с импульсами в области шириной $\Delta r \sim \Delta/v_F$. Пространственный масштаб куперовской корреляции («размер» пары) $\xi \sim \hbar/\Delta r \sim \hbar v_F/\Delta$. Ко рреляционная длина $\xi \sim 10^{-7}-10^{-4}$ см (ниж. предел реализуется у ВТСП), однако обычно ξ намного превышает период кристаллич. решётки.

Эл.-динамич. свойства сверхпроводников зависят от соотношения между стандартной коррел. д. длиной $\xi_0 = \hbar v_F/\Delta(0)$ и характерной толщиной поверхностного слоя, в к-ром существенно изменяется величина эл.-магн. поля $\delta_L = (mc^2/4\pi l n_e e^2)^{1/2}$, где n_e — концентрация сверхпроводящих (спаренных) электронов, e — заряд электрона. Если $\delta_L(T) \gg \xi_0$ (такая область всегда имеется вблизи T_c , т. к. при $T \rightarrow T_c n_e \rightarrow 0$), то куперовские пары можно считать точечными, поэтому эл.-динамика сверхпроводника является локальной и сверхпроводящий ток определяется значением векторного потенциала A в рассматриваемой точке сверхпроводника (у-ние Лондонов). При $\delta_L(T) \leq \xi_0$ проявляются когерентные свойства конденсата куперовских пар, эл.-динамика становится неповерхностной — ток в данной точке определяется значениями A в целой области размером $\sim \xi_0$ (Линдара времени). Такова обычно ситуация в массивных чистых сверхпроводниках (при достаточном удалении от их поверхности).

Переход металла из нормального в сверхпроводящее состояние в отсутствие магн. поля является фазовым переходом 2-го рода. Этот переход характеризуется комплексным скалярным параметром порядка — волновой ф-цией бозе-конденсата куперовских пар $\Psi(r)$, где r — пространственная координата. В модели БКШ $\Psi = \Delta$ и при $T = T_c$ $|\Psi| = \Delta = 0$, а при $T = 0$ $|\Psi| = \Delta(0)$. Фаза волновой ф-ции Ψ также имеет существенное значение: через градиент этой фазы определяется плотность сверхпроводящего тока j_s :

$$j_s = -\frac{ie\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) - \frac{2e}{mc} A, \quad (3)$$

где знак * обозначает комплексное сопряжение. Величина плотности тока j_s также обращается в нуль при $T = T_c$. Фазовый переход нормальный металл — сверхпроводник можно рассматривать как результат спонтанного нарушения симметрии по отношению к группе симметрии $U(1)$ калибровочных преобразований волновой ф-ции $\Psi(r)$. Физически это соответствует нарушению ниже T_c сохранения числа электронов в связи с их спариванием, а математически выражается возмущением отличных от нуля ср. значений параметра порядка $\langle \Psi(r) \rangle$.

Цель в энергетич. спектре электронов не всегда совпадает с модулем параметра порядка (как это имеет место в модели БКШ) и вообще не является необходимым условием С. Так, напр., при введении в сверхпроводник парамагн. примесей в нек-ром диапазоне их концентраций может реализовываться бесследная С. (см. ниже). Свообразна картина С. в двумерных системах, где термодинамич. флуктуация фазы параметра порядка разрушают дальний порядок (см. Мермина — Ватнера теорема), и тем не менее С. имеет место. Оказывается, что необходимым условием существования сверхпроводящего тока j_s является даже не наличие дальнего порядка (конечного ср. значения параметра порядка $\langle \Psi(r) \rangle \neq 0$), а более слабое условие степенного убывания корреляционной функции

$$\langle \Psi(r) \Psi^*(r') \rangle_{|r-r'| \rightarrow \infty} \sim \frac{1}{|r-r'|^{\alpha}}, \quad (\alpha > 0).$$

Тепловые свойства. Теплоёмкость сверхпроводника (как и нормального металла) состоит из электронной C_{el} и решётчатой C_{ph} компонент. Индекс s относится к сверхпроводящей фазе, n — к нормальной, l — к электронной компоненте, p — к решётчатой.

При переходе в сверхпроводящее состояние решётчатая часть теплоёмкости почти не меняется, а электронная увеличивается скачком. В рамках теории БКШ для изотропного спектра

$$\frac{C_{el}(T)}{C_{el}(T_c)} = \begin{cases} 2,43 + 3,77(T/T_c - 1), & T_c - T < T_c \\ 1,35(\Delta(0)/kT)^{1/2} \exp(-\Delta(0)/kT), & T < T_c. \end{cases}$$

При $T < T_c$ значение C_{el} экспоненциально убывает (рис. 3) и теплоёмкость сверхпроводника определяется своей решётчатой частью $C_{ph} \sim T^3$. Характерная экспоненциальная зависимость C_{el} даёт возможность непосредственного измерения $\Delta(0)$. Отсутствие этой зависимости свидетельствует о том, что в нек-рых точках

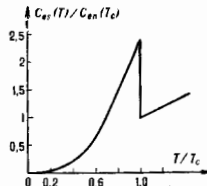


Рис. 3. Скачок теплоёмкости при переходе в сверхпроводящее состояние.

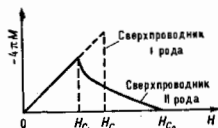
поверхности Ферми энергетич. щель обращается в нуль. По всей вероятности, последнее связано с неформальными механизмами притяжения электронов (напр., в системах с тяжёлыми фермионами, где при низких температурах $C_{el} \sim T^3$ для UB_{13} и $C_{el} \sim T^2$ для $CeCuSi_3$).

Теплопроводность κ_2 металла при переходе в сверхпроводящее состояние не испытывает скачка, т. е. $\kappa_2(T_c) = \kappa_2(T_c)$. Зависимость $\kappa_2(T)$ обусловлена рядом факторов. С одной стороны, сами электроны дают свой вклад в теплопроводность κ_{2e} , и-рый по мере понижения темп-ры и образования куперовских пар уменьшается. С др. стороны, фононный вклад κ_{2ph} начинает несколько увеличиваться, поскольку с уменьшением числа электронов увеличивается длина свободного пробега фононов (электроны, объединяемые в куперовские пары, фононов не рассеивают и сами тепло не переносят). Т. о., $\kappa_{2e} < \kappa_{2n}$, в то время как $\kappa_{2ph} > \kappa_{2n}$. В чистых металлах, где выше T_c преобладает электронная часть теплопроводности, она остаётся определяющей и при переходе в сверхпроводящее состояние; в результате $\kappa_2/\kappa_{2n} < 1$ при всех темп-рах ниже T_c . В сплавах же, наоборот, теплопроводность определяется в основном своей фононной частью и при переходе через T_c κ_2 начинает возрастать ввиду уменьшения числа неспаренных электронов.

Магнитные свойства. Благодаря возможности протекания в сверхпроводнике бесдиссипативных сверхпроводящих токов, он при опред. условиях эксперимента проявляет эффект Мейснера, т. е. ведёт себя в присутствии не слишком сильного внеш. магн. поля как идеальный диамагнетик (магн. восприимчивость $\chi = -1/4\pi$). Так, для образца, имеющего форму длины сплошного цилиндра в однородном внеш. магн. поле H , приложенном вдоль его оси, намагниченность образца $M = -H/4\pi$. Выталкивание магн. поля из объёма сверхпроводника приводит к понижению его свободной энергии. При этом вкраивающиеся сверхпроводящие токи протекают в тонком поверхностном слое $\delta \sim 10^{-3} + 10^{-4}$ см. Эта величина характеризует и глубину проникновения внеш. магн. поля в образец.

По своему поведению в достаточно сильных полях сверхпроводящие материалы делятся на две группы: сверхпроводники 1-го и 2-го рода (рис. 4). Нач. участок кривых намагничивания (где $M = -H/4\pi$) соответствует полному эффекту Мейснера. Дальнейший ход кривых у сверхпроводников 1-го и 2-го рода существенно различается.

Рис. 4. Зависимость намагниченности от внешнего магнитного поля для сверхпроводников 1-го и 2-го рода.



Сверхпроводники 1-го рода утрачивают С. скачком (фазовый переход 1-го рода): либо при достижении соответствующей данному полю критич. темп-ры $T_c(H)$, либо при повышении внеш. поля до критич. значения $H_{c1}(T)$ (термодинамич. критич. поле). В точке фазового перехода, происходящего в магн. поле, в энергетич. спектре сверхпроводника 1-го рода сразу же появляется щель конечной величины. Критич. поле $H_{c1}(T)$ определяет разность уд. свободных энергий сверхпроводящей F_s и нормальной F_n фаз:

$$F_n - F_s = H_{c1}^2 / 8\pi.$$

Кривая уд. теплота фазового перехода

$$Q = T(S_n - S_s) = -T \partial(F_n - F_s) / \partial T = -(T/4\pi) n \partial H_{c1} / \partial T,$$

где S_n и S_s — уд. энтропии соответствующих фаз. Скачок уд. теплоёмкости при $T = T_c$

$$\Delta C = C_s - C_n = (T_c/4\pi) [(\partial H_{c1} / \partial T)^2].$$

В отсутствие внеш. магн. поля при $T = T_c$ величина $Q = 0$, т. е. происходит переход 2-го рода.

Согласно модели БКШ, термодинамич. критич. поле связано с критич. темп-рой соотношением

$$H_{c1}(0) = 1,41 T_c \sqrt{\frac{2}{\mu_0} / v_F \hbar^2},$$

а его температурная зависимость в предельных случаях высоких и низких темп-р имеет вид:

$$H_{c1}(T) = H_{c1}(0) \left\{ \frac{1 - 1,06(T/T_c)^2}{1,73(1 - T/T_c)} \right\}, \quad T \ll T_c;$$

Обе предельные ф-лы близки к эмпирич. соотношению $H_{c1}(T) = H_{c1}(0) [1 - (T/T_c)^2]^2$, к-рое хорошо описывает типичные эксперим. данные (рис. 5). В случае нецелиндрич. геометрии опыта при превышении внеш. магн. полем определ. величины $H_0 = (1 - N)H_c$ (N — *размещающий фактор*) сверхпроводник 1-го рода пере-

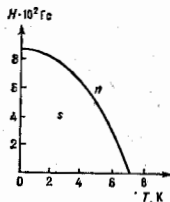


Рис. 5. Температурная зависимость термодинамического критического магнитного поля H_{c1} .

ходит в *промежуточное состояние*: образец разделяется на слои нормальной и сверхпроводящей фаз, соотношение между объёмами к-рых зависит от величины H . Переход образца в нормальное состояние происходит постепенно, путём роста доли соответствующей фазы.

Промежуточное состояние может возникнуть и при протекании по сверхпроводнику тока, превышающего некое критич. значение I_{c1} , соответствующего созданию на поверхности образца критич. магн. поля H_{c1} .

Образование в сверхпроводнике 1-го рода промежуточного состояния и чередование слоёв сверхпроводящей и нормальной фаз конечного размера оказываются возможными только в предположении, что граница раздела между этими фазами обладает положит. поверх-

ностной энергией $\sigma_{\text{пл}}$. Величина и знак $\sigma_{\text{пл}}$ зависят от соотношения между ξ и δ .

Отношение $\kappa = \delta/\xi$ наа. параметром Гинзбурга — Ландау и играет важную роль в феноменологии теории С. Знак $\sigma_{\text{пл}}$ (или значение κ) даёт возможность строго определить род сверхпроводника у сверхпроводника 1-го рода $\kappa < 1/\sqrt{2}$ и $\sigma_{\text{пл}} > 0$ для сверхпроводника 2-го рода $\kappa > 1/\sqrt{2}$ и $\sigma_{\text{пл}} < 0$. К сверхпроводникам 2-го рода относятся чистый Nb, большинство сверхпроводящих сплавов, органические и высокотемпературные сверхпроводники.

Для сверхпроводников 2-го рода $\sigma_{\text{пл}} < 0$, поэтому фазовый переход 1-го рода в нормальное состояние невозможен. Промежуточное состояние не реализуется, поскольку поверхность на границей фаз обладает как отрицат. энергией и уже не выполняла бы роль фактора, сдерживающего бесконечное дробление. Для достаточно слабых полей и в сверхпроводниках 2-го рода имеет место эффект Мейснера. При достижении ниж. критич. поля H_{c1} (в случае $\kappa \gg 1$; $H_{c1} \approx H_c \kappa^{-1} \ln \kappa$), к-рое оказывается меньше формально вычисленного в этом случае H_c , становится энергетически выгодным проникновение магн. поля в сверхпроводник в виде одиночных вихрей (см. *Квантовые вихри*), содержащих в себе по одному кванту магнитного потока. Сверхпроводник 2-го рода переходит в *смешанное состояние*.

Сердцевины вихрей пребывают в нормальном (несверхпроводящем) состоянии, параметр порядка становится зависящим от координат: он обращается в нуль на оси вихря и восстанавливается до равновесного значения на расстояниях $\sim \xi$ (размер сердцевин вихря). По периферии вихря тект сверхпроводящие токи, экранирующие магн. поле за пределами вихря. По мере дальнейшего увеличения внеш. поля число вихрей растёт — эффект Мейснера становится неполным. Между вихрями по-прежнему остаётся сверхпроводящая фаза, по к-рой может протекать незауходящий ток. Сами вихри в востроном сверхпроводнике упорядочиваются в треугольную решётку (т. я. *решётка вихрей Абрикосова*). Такая картина постепенного проникновения внеш. поля в объём сверхпроводника 2-го рода существует вплоть до верх. критич. поля H_{c2} , когда С. исчезает окончательно. При таких полях происходит разрушение куперовских пар вследствие их закручивания, т. к. пара может существовать как единое целое лишь до тех пор, пока радиус ларморовской прецессии превышает характерный размер куперовской пары ξ . Это условие и определяет поле $H_{c2} \approx \kappa H_c$.

При протекании тока в сверхпроводнике 2-го рода на вихри действует сила Ампера, что должно приводить к их движению в перпендикулярном току направлении. Однако при наличии в сверхпроводнике неоднородностей структуры последние могут удерживать решётку вихрей Абрикосова в равновесии до тех пор, пока ток не слишком велик (меньше критического). Это явление наз. *п. и н. и. г. о. м.* В условиях движения при достаточно слабом токе движение вихрей (перенос магн. потока) может осуществляться только посредством тепловой активации — флуктуац. перескоков отд. вихрей либо целых областей решётки из одних положений локального равновесия в другие (что приводит к локальным деформациям решётки). Явление полуустойчивости вихрей Абрикосова наз. *к. п. о. м. г. и. н. и. г. о. м.* Напряжение U , возникающее на образце, обусловлено движением вихрей и определяется соотношением

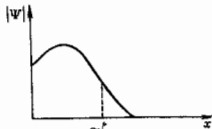
$$U \propto \exp(-\mathcal{E}_{\text{ан}}/kT),$$

где энергия активации $\mathcal{E}_{\text{ан}}$ убывает с возрастанием тока и может зависеть от внеш. магн. поля.

При определ. условиях своеобразное неоднородное сверхпроводящее состояние может реализоваться и в полях выше H_{c2} . Так, если сверхпроводник 2-го рода

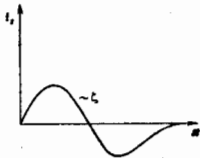
[или 1-го рода с $\kappa > (1,69\sqrt{2})^{-1}$] с плоской границей поместить в параллельное границе магн. поле H , $H_{c1} < H < 1,69H_{c2}$, то вблизи поверхности в нем образуется зарядный сверхпроводящий фазы. При этом объем материала пребывает в нормальном состоянии, сверхпроводящим оказывается лишь приповерхност-

Рис. 6. Зависимость модуля параметра порядка $|\Psi|$ от расстояния до поверхности x в случае поверхностной сверхпроводимости.



ный слой толщиной $\sim \xi$ (рис. 6). Здесь возникают пост. сверхпроводящие токи, к-рые частично выталкивают внем. магн. поле из приповерхностного слоя. Однако по мере удаления от поверхности плотность этого тока

Рис. 7. Профиль плотности сверхпроводящего тока j_x , текущего вблизи поверхности сверхпроводника в случае поверхностной сверхпроводимости, — x расстояние до поверхности.



обращается в нуль и затем меняет знак (рис. 7) так, чтобы выполнялось условие

$$\int_0^{\infty} j_x(x) dx = 0;$$

тогда магн. поле в глубине образца ($x \gg \xi$) совпадает с внешним. Если внем. поле не параллельно поверхности, в образце возникает вихревая структура, период к-рой определяется углом наклона магн. поля к поверхности (И. О. Кулик, 1967).

Квантование магнитного потока. Когерентность сосуществования бозе-конденсата куперовских пар проявляется также в квантовании магн. потока, проходящего через замкнутозамкнутый сверхпроводник (напр., полый цилиндр со стенками толщиной $d \gg \delta$ в продольном магн. поле $H < H_c$ для сверхпроводника 1-го рода или $H < H_{c1}$ для сверхпроводника 2-го рода). Магн. поток Φ , заключенный в этом цилиндре, может иметь лишь определ. дискретные значения: $\Phi = n\Phi_0$, где n — целое число. Величина кванта магн. потока $\Phi_0 = hc/2e = 2,07 \cdot 10^{-7}$ Э.см² весьма мала, поэтому эффект квантования проявляется лишь в очень прецизионных экспериментах. Наблюдение на опыте теоретич. предсказанной величины кванта Φ_0 стало одним из подтверждений сосуществования куперовских пар, т. к. если бы носителями заряда в сверхпроводнике служили отд. электроны, то квант магн. потока должен был бы иметь вдвое большую величину (см. Ааронова — Вома эффект). Квантованность магн. потока существенна для понимания поведения сверхпроводника 2-го рода и в магн. полях выше H_{c1} , т. к. внем. поле проникает в него в виде отд. вихрей, каждый из к-рых несет в себе один квант магн. потока, что определяет само число вихрей.

Описанная картина квантования магн. потока может нарушиться в случае своеобразного термоэлектрич. эффекта в сверхпроводящем кольце из двух разл. сверхпроводников, спаян к-рых поддерживаются при разл. темп-рах T_1 и T_2 , помещенном в магн. поле. В этом случае величина потока может отличаться от целого числа квантов. Обусловленная термоэлектричеством выделенная добавка зависит от темп-р:

$$\Phi/\Phi_0 = (m/\pi\hbar) \int_0^T \left[(\kappa_a/\mu_n)_a - (\kappa_b/\mu_n)_b \right] dT,$$

где индексы a и b относятся к первому и второму сверхпроводникам, κ_a — теплопроводности, μ — хим. потенциал, n_a — число сверхпроводящих электронов.

Роль примесей. Обычные немагн. примеси оказывают весьма слабое влияние на термодинамич. свойства сверхпроводников. Их относят, вклад в эти свойства определяется величиной $(a/l) \sim c$, где a — межатомное расстояние, l — длина свободного пробега электрона, определяющаяся рассеянием на примесях, c — концентрация примесей. Немагн. примеси действуют только на элктрич. заряд и одинаковым образом рассеивают оба спаренных электрона, не разрушая куперовскую пару. Однако при увеличении концентрации примесей величина l уменьшается и становится сравнимой со стандартной корреляц. длиной ξ_0 . Характер движение спаренных электронов меняется с баллистического (без рассеяния) на диффузионный. При этом если $l \ll \xi_0$, то эфф. корреляц. длина $\xi = \sqrt{l\xi_0}$ зависит от длины свободного пробега. Убывание ξ с ростом концентрации примесей (при соответств. значениях l) меняет эл.-динамич. и кинетич. свойства сверхпроводника, увеличивает относит. вклад сверхпроводящих флуктуаций (см. ниже).

Совершенно иное влияние на С. оказывают примеси парамагн. атомов. Благодаря обменному взаимодействию между спином примеси и спинами электронов, образующих куперовскую пару, рассеяние на такой примеси может привести к переходу пары в триплетное состояние (когда спин пары равен 1) и, вследствие Паули принципа, к её разрушению. Т. о., введение парамагн. примесей в образец приводит к подавлению С. При очень малой концентрации таких примесей ($l_a \gg \xi$, l_a — длина свободного пробега с первоотом спина) уменьшение T_c оказывается обратно пропорциональным l_a :

$$\Delta T_c/T_c \approx \xi/l_a.$$

Когда кон-ция парамагн. примесей достигает нек-рого критич. значения $c_{кр}$ и l_a становится порядка ξ ($c_{кр}$ — неск. атомных %), T_c обращается в нуль (исключением составляет *магнитные сверхпроводники*).

При введении в сверхпроводник парамагн. примеси энергетич. щель Δ в спектре электронов обращается в нуль несколько раньше, чем T_c , при кон-ция 0,915 $c_{кр}$. В узком диапазоне кон-ций 0,915 $c_{кр} <$

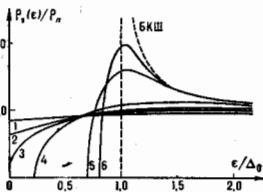


Рис. 8. Зависимость одноэлектронной плотности состояний в сверхпроводнике ρ , от энергии ϵ для различных концентраций парамагнитных примесей. Возрастание номеров кривых 1—6 идет в порядке уменьшения концентрации примесей. Кривые 1—3 соответствуют бесщелевой сверхпроводимости. Зависимость, описанная моделью БКШ, выделена пунктиром. (Плотность состояний в нормальном металле $\rho_n = c/v_F$, Δ_0 — параметр порядка при $T = 0$.)

$< c < c_{кр}$ реализуется необычное состояние бесщелевой С. (А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, 1960), когда явление С. и эффект Мейснера имеют место, а щель в спектре уже нет (рис. 8). Зависимость теплоёмкости сверхпроводника от темп-р в таком состоянии ста-

новятся линейной (а не экспоненциальной), изменяются характер температурных зависимостей теплопроводности, коэф. поглощения звука, ал.-магн. излучения.

Магн. примеси не только уменьшают энергию связи куперовских пар, но и приводят к определенному их распределению по энергиям связи. В результате не все куперовские пары имеют одинаковую энергию и пребывают в конденсате — часть из них имеет меньше энергии связи и находится в возбужденном состоянии. Параметром порядка k в этом случае является когерентная волновая ф-ция бозе-конденсата, однако теперь $|\Psi|$ не определяет величину щели в энергетич. спектре. Наб. отчетливо это проявляется в режиме бесщелевой S_c , когда бозе-конденсат ещё существует, а спектр электронных возбуждений уже становится бесщелевым.

Парамагн. примеси не единств. источник разрушения куперовских пар. Любое возмущение, неизменяемое относительно замены знака времени в гамма-квантовые системы, приводит к тому же эффекту. Куперовские пары являются суперпозицией состояний электронов с противоположными импульсами и спинами, к-рые переходят друг в друга при инверсии времени $t \rightarrow -t$, поэтому возмущение, неизменяемое относительно этого преобразования, разрушает пары. Таким возмущением могут быть внеш. магн. поле (з. эффект, проявляющийся в тонких плёнках), протекающий ток, неоднородное сверхпроводящее состояние.

Найтковский сдвиг. Частота ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для одного и того же ядра зависит от того, входит ли оно в состав диэлектрика или металла. В металле вероятность нахождения электронов проводимости вблизи ядра несколько возрастает. Эти электроны намагничиваются внеш. полем, и з.эф. магн. поле, действующее на спин ядра, увеличивается, что приводит (по сравнению с диэлектриком) к т. н. найттовскому сдвигу частоты ЯМР. Поскольку магн. восприимчивость нормального металла χ_n практически не зависит от темп-ры, то постоянная остаётся и найттовский сдвиг ЯМР можно наблюдать и в сверхпроводниках, если использовать тонкие плёнки или малые гранулы с характерными размерами, меньшими глубины проникновения δ . В таких образцах ниже T_c величина найттовского сдвига зависит от темп-ры и остаётся конечной даже при $T = 0$. При этом

$$\frac{\chi_n(0)}{\chi_n} \left\{ \frac{(\pi^2/16) \xi_{n0} / l_{00}}{(1-3/4) l_{00} / \xi_{n0}}, \xi_{n0} \ll l_{00} \right.$$

где $\chi_n(0)$ — магн. восприимчивость сверхпроводника при $T = 0$, l_{00} — длина свободного пробега электрона с переносом спина, обусловленным спин-орбитальным взаимодействием. На первый взгляд эти проверенные экспериментально ф-лы противоречат модели БКШ, т. к. в этой модели при $T = 0$ все электроны объединены в куперовские пары с полным спином, равным нулю. Разрыв куперовской пары требует затрат энергии $\sim \Delta(0)$. Поэтому в сверхпроводнике не должно быть испаренных электронов, способных создать отклик на слабое внеш. поле, и $\chi_n(0) = 0$. В действительности же в малых частях и тонких плёнках, где наблюдается найттовский сдвиг, весьма существенно рассеяние на границах, в к-ром проявляется и спин-орбитальное взаимодействие. При учёте этого взаимодействия электронный спин перестаёт сохраняться, и классификация по полному спину электронной системы S становится невозможной. Даже в осн. состоянии сверхпроводника появляется примесь состояний с $S \neq 0$, что и делает возможным поляризацию в слабом магн. поле.

Высокочастотные свойства. Поглощение ал.-магн. излучения в сверхпроводнике при $T = 0$ обусловлено разрушением куперовских пар. Поэтому излучение с частотами $\omega < \omega_c = 2\Delta(0)/\hbar$ отражается от поверхности сверхпроводника (ω_c — пороговая частота). Характерные пороговые длины волн для традиционных

сверхпроводников лежат в диапазоне 0,1—1 мкм ($\omega_c \sim 10^{11} - 10^{12}$ Гц). Для $\hbar\omega \gg 2\Delta(0)$ различие между сверхпроводником и нормальным металлом стирается. Это относится к отражению в оптич. диапазоне, однако наличие куперовских пар может привести здесь к своеобразному комбинационному рассеянию света. При отражении ал.-магн. излучения от поверхности сверхпроводника его спектральный состав включает в себя, кроме основной гармоники (с частотой ω_0), стоксовские «стеллиты», соответствующие потере энергии на разрыв пар. Их частоты непрерывно распределены в диапазоне $0 < \omega_{\pm} < \omega_0 - 2\Delta(0)/\hbar$, причём их относительная интенсивность чрезвычайно мала. При $T > 0$ в сверхпроводнике имеются испаренные электроны, к-рые могут поглощать ал.-магн. кванты любой частоты, и описанные выше пороговые явления размываются.

Высокочастотное, $\hbar\omega \sim 2\Delta$, ал.-магн. поле большой интенсивности при воздействии на сверхпроводник может привести к повышению критич. темп-ры T_c сверхпроводящего перехода (Г. М. Эдлинберг, 1970). Если образец поддерживать при темп-ре несколько выше T_c и облучать, то он может скачком перейти в сверхпрово-

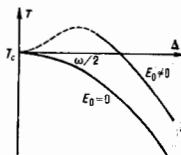


Рис. 9. Изменение температурной зависимости энергетической щели Δ при поглощении высокочастотного электромагнитного излучения $E_0 \cos \omega t$ в случае тонкой сверхпроводящей плёнки.

дующее состояние с конечной Δ (В. М. Дмитриев и др., 1966) (рис. 9). Роль ал.-магн. волны может играть и мощная звуковая волна подходящей частоты.

Частоты ультразвука, к-рые можно реально генерировать в сверхпроводнике, не превышают 10^9 Гц, что, намного меньше пороговой частоты $\omega_c \sim 10^{11}$ Гц. Поэтому при $T \rightarrow 0$ в поглощении ультразвука могут принимать участие лишь испаренные электроны (число к-рых экспоненциально мало) и в этом случае коэф. поглощения звука оказывается значительно меньше, чем в нормальном металле.

Флуктуационные явления. Появление термодинамически неравновесных куперовских пар (сверхпроводящих флуктуаций) при темп-рах выше T_c приводит к тому, что сверхпроводник, пребывая ещё в своей нормальной фазе, как бы заранее «предчувствует» приближение сверхпроводящего перехода. В непосредственной окрестности выше T_c могут заметно возрастать его проводимость и теплоёмкость, коэф. поглощения звука, термозд и коэф. Холла и др. Увеличение теплоёмкости сглаживает скачок, имеющий место в самой точке перехода. Для чистого массивного сверхпроводника область темп-р ΔT , в к-рой существенно влияние флуктуаций, можно оценить как $\Delta T/T_c \sim \sim (a/\xi)^2 \sim 10^{-11} [(a/\xi)^2]$ — параметр Гинзбурга — Ландау в а. е., показатель степени зависит от размерности системы). Эти эффекты становятся гораздо более заметными в сплавах и низкоразмерных сверхпроводниках благодаря уменьшению з.эф. корреляц. длины и степени в параметре Гинзбурга — Ландау. Для аморфных плёнок и итевидных кристаллоидов (вискерсов) флуктуационная область темп-р расширяется вплоть до $\Delta T/T_c \sim 10^{-3} - 10^{-1}$. Избиточная проводимость тонкой аморфной плёнки толщиной d при $T > T_c$

$$\Delta\sigma_H = (e^2/4\hbar d) T_c (T - T_c).$$

Эта поправка обусловлена дополнительным, по сравнению с одноэлектронным, механизмом переноса заряда флуктуационно возникающими куперовскими парами (прямой вклад Асламазова — Ларкина, или d а d а d

проводимости). Сверхпроводящие флуктуации определяют топкую структуру аномалий вольт-амперных характеристик туннельных и джозефсоновских контактов, длинные «хвосты» в диамагн. восприимчивости и др. явления в сверхпроводящих системах вблизи T_c .

Лит.: Д. Жей П., Сверхпроводимость металлов и сплавов, пер. с англ., М., 1958; Шрэд Ферр Дж., Теория сверхпроводимости, пер. с англ., М., 1970; Бонсовени и С. В., Изюмов Ю. А., Курмаев Э. З., Сверхпроводимость переходных металлов, их сплавов и соединений, М., 1977; Тинириам М., Введение в сверхпроводимость, пер. с англ., М., 1980; Шмидт В. В., Введение в физику сверхпроводников, М., 1982; Абрикосов А. А., Основы теории металлов, М., 1987; Superconductivity, ed. by R. D. Parks, v. 1—2, N. Y., 1969. А. А. Варламов.

СВЕРХПРОВОДНИКИ — вещества, у которых при охлаждении ниже определенной критич. темп-ры T_c электрич. сопротивление падает до нуля, т. е. наблюдается *сверхпроводимость*. За исключением благородных (Cu, Ag, Au, Pt), щелочных (Li, Na, K и др.), щёлочноземельных (Be, Mg и др.) и ферромагнитных (Fe, Co, Ni) металлов, б. ч. остальных металлах. элементов является С. (см. табл. в ст. *Металлы*). Элементы Si, Ge, Bi, Te становятся С. при охлаждении под давлением. Переход в сверхпроводящее состояние обнаружен у неск.

С ростом темп-ры значения всех критич. магн. полей монотонно падают и обращаются в нуль при $T = T_c$. Макс. значения $H_c = H_0$ (или $H_{c2} = H_0$), определенно из эксперим. данных путём экстраполяции к $T = 0$, для нек-рых С. приведены в табл.

Предельная величина постоянного электрич. тока, протекающего по С. без диссипации энергии, наз. *критическим током* I_c . В массивном С. 1-го рода величина I_c определяется током, создающим на поверхности С. поля H_c . В С. 2-го рода значение I_c определяется образованием и движением вихревых токов.

Все чистые металлы, за исключением V и Nb, и нек-рые сплавы с низким содержанием одного компонента являются С. 1-го рода. Группа С. 2-го рода гораздо многочисленнее. Сюда относятся классические С. с высокими значениями T_c и ВТСП.

Среди С. 2-го рода выделяют группу т. п. жёстких и х С. Для них характерно большое кол-во дефектов структуры (неоднородности состава, вакансии, дислокации и др.), к-рые возникают благодаря спец. технологии изготовления. В жёстких С. движение магн. потока сильно затруднено дефектами и тривные *магнитичекие* обнаруживают сильный *гистерезис*. В этих материалах сильные сверхпроводящие токи (плотностью до $10^8 - 10^9$ А/см²) могут протекать вплоть до полей, близких к верхнему критич. полю H_{c2} при любой ориентации тока и магн. поля. В идеальном С. 2-го рода, полностью лишённом дефектов (к этому состоянию можно приблизиться в результате длительного отжига сплава), при любой ориентации поля и тока, за исключением продольной, сколь угодно малый ток будет сверхпроводиться потерями на движение магн. потока уже при $H > H_{c1}$. Такие С. 2-го рода наз. *мягкими*. Значение H_{c1} обычно во много раз меньше H_{c2} . Поэтому именно жёсткие С., у к-рых электрич. сопротивление практически равно нулю вплоть до очень сильных полей, представляют интерес с точки зрения техн. приложений. Их применяют для изготовления обмоток *сверхпроводящих магнитов* и др. целей. Существование недостатков жёстких С. является их хрупкостью, сильно затрудняющая изготовление из них проволоч или лент. Особенно это относится к классич. соединениям с самыми высокими значениями T_c и H_c типа V_3Ga , Nb_3Sn , $PbMo_0.8S_8$. Изготовление сверхпроводящих магн. систем из этих материалов — сложная технов. задача.

Огромные значения критич. полей H_0 для ВТСП, определённые путём экстраполяции результатов измерений при высоких темп-рах, открывают принципиально новые перспективы использования этих материалов, однако техн. проблемы, связанные с их применением, ещё не решены.

Лит.: Сверхпроводящие материалы. Сб. ст., пер. с англ., М., 1965; Металловедение сверхпроводящих материалов, М., 1969; Физико-химия сверхпроводников, М., 1976; Высокомтемпературные сверхпроводники, пер. с англ., М., 1988. И. И. Крюков.

СВЕРХПРОВОДНИКИ ВТОРОГО РОДА — сверхпроводящие материалы, составляющие один из двух классов, на к-рые подразделяются все сверхпроводники в зависимости от поведения в магн. поле.

Длинный цилиндр из С. в. р., помещённый в продольное магн. поле, обнаруживает полный *Мейснера эффект* лишь в полях, не превосходящих ниж. критич. поля H_1 (см. *Критическое магнитное поле*, *Сверхпроводимость*). В полях с напряжённостью выше H_1 и ниже H_2 (верх. критич. поле) магн. поток начинает проникать в цилиндр, образуя, однако даже при установлении термодинамич. равновесия поток, проходящий через цилиндр, имеет меньшую величину, чем в случае, когда образец находится в нормальном состоянии (неполный эффект Мейснера). Это указывает на наличие незатухающих токов в образце, к-рый, следовательно, находится ещё в сверхпроводящем состоянии. Образец полностью переходит в нормальное состояние в полях с напряжённостью выше H_2 (рис. 1). Вблизи поверхности образца из С. в. р. возможно об-

Вещество	Критическая температура, T_c , К	Критическое поле, H_c , Э
Сверхпроводники 1-го рода		
Свинец	7,2	800
Таллий	4,5	530
Олово	3,7	310
Алюминий	1,2	100
Ванн	0,88	53
Вольфрам	0,012	1,0
Сверхпроводники 2-го рода		
Нйобий	9,2	2000
Сплав НТ-50 (Nb—Ti—Zr)	9,7	10000
Nb ₃ A	14	21000
PbMo _{0.8} S ₈	15	60000
Nb ₃ Sn	18	25000
TlBa ₂ Ca ₂ O ₇	93	150000

соединения сплавов и соединений и у нек-рых *слабомагнитных полупроводников*. Ряд сверхпроводящих сплавов состоит из компонент, не являющихся С. Открыты *органические сверхпроводники* и полимеры, напр. (SN)_x, $T_c = 0,34$ К. По величине T_c в силу историч. причин С. делятся на классические, у к-рых $T_c < 30$ К, и высокотемпературные С. (ВТСП) с характерными значениями $T_c \sim 100$ К (см. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*).

Наряду с потерей сопротивления важнейшим свойством С. является вытеснение магн. поля из массивного образца (*Мейснера эффект*). В силу этого все С. являются *диамагнетиками*. Слабое магн. поле проникает лишь в тонкий поверхностный слой ≈ 1000 Å и менее. По своему поведению в магн. поле С. делятся на две группы: С. 1-го и 2-го рода. В С. 1-го рода проникновение магн. поля в глубь образца и восстановление сопротивления происходит в определённом критич. поле H_c . При $H \geq H_c$ С. 1-го рода переходит в нормальное — несверхпроводящее состояние. В С. 2-го рода проникновение магн. поля (а в виде вихревых нитей, т. е. вихрей сверхпроводящего тока, каждый из к-рых несёт *квант магнитного потока*) начинается в ниж. критич. поле H_1 и заканчивается в верхнем H_2 . Электрич. сопротивление восстанавливается в осн. вблизи H_{c2} . При $H \geq H_{c2}$ вещество становится полностью нормальным (см. также *Критическое магнитное поле*, *Сверхпроводящие первого рода*, *Сверхпроводники второго рода*, *Решётка вихрей Абрикосова*).

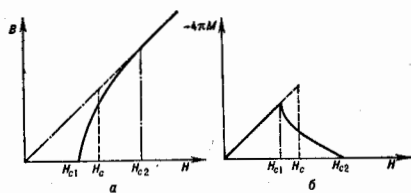


Рис. 1. Зависимость магнитной индукции (а) и намагниченности (б) для длинного сверхпроводящего цилиндра от напряженности продольного магнитного поля. Сплошная линия — сверхпроводник 2-го рода, пунктирная — сверхпроводник 1-го рода.

разование тонкого сверхпроводящего слоя толщиной порядка длины когерентности при напряженности магн. поля в интервале $H_{c2} < H < H_{c3}$ (поверхностная сверхпроводимость). Ниже фазовая диаграмма схематически показана на рис. 2. У С. в. р. (в отличие

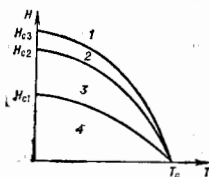


Рис. 2. Фазовая диаграмма для сверхпроводника 2-го рода в форме длинного цилиндра в продольном магнитном поле: 1 — нормальное состояние; 2 — поверхностная сверхпроводимость; 3 — смешанное состояние; 4 — полный эффект Мейснера.

от С. 1-го рода) переходы в магн. поле являются фазовыми переходами 2-го рода (см. *Фазовый переход*).

Идея о существовании в природе двух родов сверхпроводников высказана впервые в 1952 А. А. Абрикосовым и Н. В. Зваричем на основе эксперим. результатов Л. В. Шубникова с соавторами по кривым намагничивания сверхпроводящих сплавов (1937) и данных Н. В. Зварича по критич. полям тонких сверхпроводящих плёнок. Для С. в. р. в магн. поле неустойчивость по отношению к образованию зародышей сверхпроводящей фазы в нормальной возникает раньше, чем становится выгодным переход всего объёма образца в сверхпроводящее состояние. При этом граница раздела нормальной и сверхпроводящей фаз имеет отриц. энергию, в отличие от С. 1-го рода, где эта энергия положительна. В результате при достаточно большом магн. поле (выше H_{c1}) С. в. р. разбивается на большое кол-во чередующихся нормальных и сверхпроводящих областей, причём нормальные области несут квантовое значение магн. потока (см. *Квантование магнитного потока*).

Микроскопич. параметром, характеризующим принадлежность сверхпроводника к 1-му или 2-му роду, является отношение глубины проникновения магн. поля λ к длине когерентности ξ : $\kappa = \lambda/\xi$, называемое параметром Гинзбурга — Ландау (см. *Гинзбург — Ландау теория*). Если $\kappa > 1/\sqrt{2}$, то материал является С. в. р. Среди чистых металлов к С. в. р. относится Nb. По мере введения примесей в С. в. р. материалы, являвшиеся С. 1-го рода в «чистом» состоянии, могут превращаться в С. в. р. Длина когерентности в сплавах $\xi \sim (\xi_0)^{1/2}$, где ξ_0 — длина когерентности чистого материала, а l — длина свободного пробега электронов в сплаве. Длина когерентности ξ может стать значительно короче ξ_0 уже при не очень большой (~1%) концентрации примесей. Глубина проникновения в сплавах $\lambda \sim \lambda_0(\xi_0/l)^{1/2}$ (где λ_0 — глубина проникновения для чистого материала), напротив, воз-

растает при введении примесей, поэтому для сплавов $\kappa = 0,75\lambda_0/l$. Т. о., практически все сплавы (я неупорядоченные плёнки) являются С. 2-го рода. К С. в. р. принадлежат также оксидные высокотемпературные сверхпроводники.

Теория С. в. р. основывается на идее А. А. Абрикосова (1957) о наличии в них квантованных вихрей, образующих двумерную решётку (см. *Решётка вихрей Абрикосова*). Такие вихри существуют в интервале $H_{c1} < H < H_{c2}$ (смешанное состояние) и определяют термодинамич. и транспортные свойства С. в. р., в т. ч. макс. электр. ток, к-рый может протекать по такому сверхпроводнику без сопротивления (*критический ток*). В присутствии электр. тока на вихрь действует *Лоренца сила*. Если вихри не закреплены на дефектах или неоднородностях материала, то они приходят в движение, в результате чего индуцируется электр. поле и происходит диссипация энергии. В этом случае критич. ток равен нулю. Если образец не находится во внеш. магн. поле, то критич. ток совпадает с током, создающим на поверхности образца магн. поле, равное H_{c2} , когда начинают образовываться вихри. Если же вихри закреплены на неоднородностях материала (и в н и в н г), то критич. ток определяется равенством силы Лоренца и силы пиннинга, удерживающей вихрь. Неоднородности материала можно создавать искусственно, повышая тем самым критич. ток пиннинга. Материалы с большим критич. током пиннинга (до 10^6 А/см²) наа. жёсткими сверхпроводниками. Такие материалы используются для изготовления сильных сверхпроводящих магнитов.

Лит.: Сан Жам Д., Сарма Г., Томас Е., Сверхпроводимость второго рода, пер. с англ., М., 1970; Кембл Ф. и А. Н. в т. 2 Д. и. Критические токи в сверхпроводниках, пер. с англ., М., 1973; Горьков Л. П., Зварич Н. и Н. Б., Движение вихрей и электросопротивление сверхпроводников второго рода в магнитном поле, «УФН», 1973, т. 118, в. 3, с. 433.

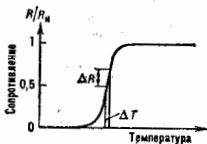
СВЕРХПРОВОДНИК ПЕРВОГО РОДА — Н. В. Коткин. Сверхпроводящие материалы, составляющие один из двух классов, на к-рые подразделяются все сверхпроводники в зависимости от их поведения в магн. поле. Цилиндр из С. п. р., помещённый в продольное магн. поле с напряжённостью H , меньшей термодинамич. критич. поля H_c (см. *Критическое магнитное поле*), обнаруживает полный *Мейснера эффект* (если образец не имеет неоднородностей), в отличие от *сверхпроводников 2-го рода*, у к-рых наблюдается неполный эффект Мейснера в определённом интервале магн. полей. При увеличении магн. поля выше H_c цилиндр из С. п. р. полностью переходит в нормальное состояние. Если образец из С. п. р. имеет произвольную форму, то при помещении его в магн. поле вблизи нек-рых участков поверхности образца напряжённость H может оказаться больше H_c (см. *Размагничивание*), и то время как вблизи др. участков поверхности $H < H_c$. В таком случае образуется структура с чередующимися нормальными и сверхпроводящими областями (доменами) — т. н. *промежуточное состояние*. Интервал магн. полей, в к-ром реализуется промежуточное состояние С. п. р., зависит от формы образца и его ориентации относительно магн. поля. В пластине, помещённой в магн. поле, перпендикулярное её поверхности, промежуточное состояние реализуется в интервале $0 < H < H_c$, для шара этот интервал $H/2H_c < H < H_c$; своеобразное промежуточное состояние реализуется в цилиндрич. проволоке, несущей ток, такой, какой, что создаваемое им магн. поле на поверхности превышает H_c . На границе нормальной и сверхпроводящей областей магн. поле затухает в глубь сверхпроводящего домена на расстоянии порядка глубины проникновения λ , а сверхпроводящий параметр порядка восстанавливается на длине когерентности ξ (см. *Сверхпроводимость*). Доменная граница имеет положительную поверхностную энергию в отличие от С. 2-го рода, у к-рого она отрицательна. Микроскопич. параметром, определяющим принадлежность сверхпроводников к 1-му или 2-му роду, является

параметр Гинзбурга — Ландау $\kappa = \lambda/\xi$; у С. п. р. $\kappa < 1/\sqrt{2}$. Перехода между нормальным и сверхпроводящим состоянием в магн. поле у С. п. р. являются *фазамими переходами* 1-го рода. При охлаждении образца С. п. р., помещенного в магн. поле, происходит выталкивание магн. потока за счёт движения доменных границ. Если такое движение затруднено неоднородностями образца, то происходит «замораживание» магн. потока; в таком неравновесном состоянии может наблюдаться непольный эффект Мейснера. Практически все чистые металлы за исключением Nb относятся к С. п. р.

Н. Б. Копкин.
СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ — применяемые устройства, основанные на изменении состояния сверхпроводника (или системы сверхпроводников) под действием излучения. Использование сверхпроводников, обладающих малым уровнем шума и сильно нелинейными свойствами, позволяет достигнуть высокой чувствительности С. п. и., приближающейся к теоретич. (квантовому) пределу. Наиб. распространение получил след. вид С. п. и.: сверхпроводниковые *болометры*, применяемые на основе *Джозефсона эффекта* (тунелирование спаренных электронов) и приемники на основе одночастотного тунелирования.

Чувствительным элементом (ЧЭ) сверхпроводникового болометра (СБ) является сверхпроводящая плёнка (СП), находящаяся при темп-ре, фиксированной на крутом участке кривой перехода плёнки из нормального в сверхпроводящее состояние (рис. 1). Незначит. нагрев плёнки (на $\sim 10^{-4}$ К) потоком эл.-магн. излучения

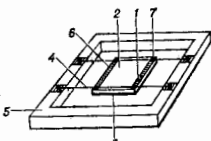
Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления плёнки R при переходе её из нормального в сверхпроводящее состояние. R_N — сопротивление плёнки в нормальном состоянии. Под действием излучения температура плёнки увеличивается на ΔT , её сопротивление на ΔR .



вызывает заметное изменение её сопротивления и напряжения на ней (при фиксир. токе), к-рое и регистрируется маломощным усилителем. Чувствительность СБ пропорциональна крутизне кривой перехода и поэтому использование материалов с узкими сверхпроводящими переходами является предпочтительным. СП должна удовлетворять и другим, часто противоречивым требованиям: высокое ул. сопротивление в нормальном состоянии, малая толщина, слабая зависимость чувствительности от частоты излучения, малая теплоёмкость и др.

Для достижения высокой чувствительности наиб. выгодным оказалось разделение ф-ций поглощения излучения и реагирования на вызываемый им нагрев. Этот принцип реализован в т. ч. составном болометре, простейшая схема к-рого представлена на рис. 2. В этом болометре ЧЭ (1) — СП из Al. Она нанесена на одну из сторон тонкой сафировой подложки (2), с др. стороны подложки нанесена плёнка Вп (3), поглощающая излучение. Подложка подвешена на тонких нейлоновых нитях (4), к-рые крепятся к массивной медной

Рис. 2. Схема основного узла составного сверхпроводящего болометра: 1 — сверхпроводящая плёнка из Al; 2 — сафировая подложка; 3 — плёнка из Вп; 4 — нейлоновые нити; 5 — медная рама; 6 — висмутовый нагреватель подложки; 7 — контакты на In.



рамке (5) — термостату с большой постоянной времени ($\tau \sim 10$ с). Висмутовая плёнка имеет значит. сопротивление и высокий коэф. поглощения, величина к-рого практически не зависит от длины волны излучения. Находясь в хорошем тепловом контакте с ней плёнка Al обладает узким сверхпроводящим переходом ($\Delta T \sim 10^{-3}$ К) и обеспечивает высокий коэф. преобразования. Включение СП в измерительную схему осуществляется при помощи тонких плёнок из индия, нанесённых на нейлоновые нити (4).

СБ работает в режиме прямого детектирования излучения, к-рое обычно модулируется с НЧ (~ 10 Гц). Пороговая чувствительность $P_{\text{д}}$ СБ, т. е. мощность, вызывающая изменение напряжения на плёнке, равно среднеквадратичному шумовому напряжению на ней (см. *Шумы* в радиоволектронике), определяется шумом ЧЭ. На практике в высокочувствит. СБ осн. шум обусловлен термодинамич. флуктуациями темп-ры при переносе теплоты от ЧЭ к термостату. Этот шум обычно превосходит джоосовский шум (*белый шум*) активного сопротивления плёнки, а также шум, вызываемый флуктуациями фонового излучения. В этом случае $P_{\text{д}} \approx (4kT^2G)^{-1}$, где G — коэф. тепловой связи ЧЭ с термостатом. Постоянная времени СБ определяется соотношением $\tau = C/G$, где C — теплоёмкость ЧЭ. С учётом этого $P_{\text{д}} \sim \tau^{-1}$ и ухудшается при уменьшении τ , а при фиксированном τ она улучшается с уменьшением C .

Высокочувствительными считаются СБ с $P_{\text{д}} = 10^{-12} - 10^{-14}$ Вт/Гц $^{1/2}$, обладающие довольно значит. инерционностью ($\tau = 10^{-1} - 10^{-4}$ с. Чувствительность описанного выше составного болометра достигает $P_{\text{д}} = 3 \cdot 10^{-15}$ Вт/Гц $^{1/2}$ при частоте модуляции 2 Гц. Для увеличения быстродействия СБ (ведущего к соответствующей потере чувствительности) СП наносится на массивную подложку через теплоизолирующую прослойку, либо СП находится в тепловом контакте с жидким гелием, что обеспечивает быстрый отвод от неё теплоты. Постоянная времени таких СБ уменьшается до $10^{-2} - 10^{-10}$ с, а $P_{\text{д}} = 10^{-2} - 10^{-12}$ Вт/Гц $^{1/2}$.

Деятелье приемников излучения с джоосовскими переходами (ДП) основывается на видеоизменении нелинейных вольт-амперных характеристик (ВАХ) этих переходов под действием эл.-магн. излучения. На рис. 3 схематически представлена ВАХ ДП с непосредств. проводимостью (мостик, точечный контакт) как в отсутствие, так и при наличии внеш. излучения.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) джоосовского перехода с непосредственной проводимостью. Сплошная кривая — ВАХ без действия излучения, штриховая кривая — ВАХ при действии излучения, штрихпунктир — нагретая кривая. I_c — критический ток, ΔV — измеренное напряжение под действием излучения.



Воздействие излучения (с частотой f) сводится в осн. к подвижному критич. току I_c и появлению вертикальных ступеней при напряжениях $V_n = nh/2e$ (n — целое число, соответствующее номеру ступени). Ступени на ВАХ обусловлены нелинейным взаимодействием в переходе колебаний тока — собственных (джозефсоновских) и наведённых внеш. излучением. В режиме квадратичного детектирования ДП включается в цепь с заданным током и при понижении I_c происходит изменение отклонения на ДП ΔV , к-рое и регистрируется как отклик приёмника. Для малых амплитуд наведённого тока $I \ll I_c$ величина отклика $\Delta V \approx \beta I^2$. В случае значит. частот ΔV определяется кривизной ВАХ и не зависит от частоты. Этот случай типичен случаю обычного классич. детектирования излучения нелинейным элементом. В области высоких частот ве-

личина отклика пропорциональна дифференц. сопротивлению R_d ДП и обратно пропорциональна β . Для смещений вблизи ступеньки отклик резонансным образом зависит от f , т. е. является селективным. В основу конструкции квадратных детекторов положена схема обычного модуля, *радиометра*, а в качестве ЧЭ чаще всего используется сверхпроводящий точечный контакт, смещение на к-ром задается в максимуме R_d . В области высоких частот ($f \sim 100\text{--}200$ ГГц) лучшие из полученных значений R_d достигают $10^{-14}\text{--}10^{-15}$ Вт/ГГц^{1/2}. Спектральная область чувствительности детекторов простирается до ~ 1000 ГГц, при этом, однако, R_d ухудшается с ростом f .

В гетеродинах приёмники излучения нелинейного ВАХ ДП используются для смещения поступающего сигнала с частотой f с сигналом внеш. гетеродина f_H и с дальнейшим усилением по промежуточной частоте $f_{\Sigma} = |f - f_H|$. Общая схема приёмника аналогична обычным гетеродинам приёмникам с нелинейным смесительным элементом (см. *Радиоприёмные устройства*). Наилучшая эффективность преобразования частот получается при значениях смещения на ДП в точке максимума R_d (обычно между 0 и V_1 — первой ступеньки). Чувствительность приёмника к смещению зависит от величины шума, добавляемого при преобразовании частоты сигнала к f_{Σ} , и обычно характеризуется соответствующей шумовой температурой T_N . Сильная нелинейность ВАХ и наличие в ДП собств. генерации создают условия для преобразования сигнала по частоте не только полезного сигнала, но и ш. ВЧ-компонентов шума. В результате, как показывают теория и эксперимент, T_N смесителя на основе ДП в десятки раз превышает его фаз. темп-ру. Частотная область использования смесителей с ДП составляет $30\text{--}500$ ГГц. Для частот ~ 100 ГГц наименьшее достигнутое значение T_N равняется ≈ 100 К. Как квадратичные детекторы, так и гетеродинае приёмники на основе ДП широко не применяются. Причина этого в недостаточной стабильности свойств обычно используемых в них сверхпроводящих точечных контактов и в повн. уровне шума. Вместе с тем по своим возможностям они в ВЧ-области ($100\text{--}1000$ ГГц) превосходят, по-видимому, приёмники, основанные на Шоттки эффекте и одночастотных туннельных переходах (см. *Туннельный эффект*).

В туннельных переходах сверхпроводник — изолятор — сверхпроводник (СИС) при напряжении смещения $V = 2\Delta/e$, где Δ — ширина энергетич. щели сверхпроводника, начинается туннелирование от. электронов, к-рому соответствует резкий рост тока через переход (рис. 4). Большая величина ВАХ такого одно-

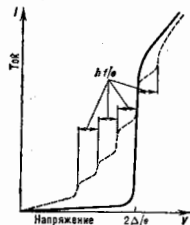


Рис. 4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) туннельного перехода сверхпроводник — изолятор — сверхпроводник. Сплошная кривая — ВАХ без действия излучения, штриховая кривая — ВАХ при действии излучения с частотой f .

частичного туннелирования может быть использована для прямого детектирования эл.-магн. излучения. Отклик приёмного элемента СИС в этом случае определяется как изменение тока через переход на единицу мощности падающего излучения. В случае низких частот отклик пропорционален крутизне ВАХ, а при частотах $hf > \delta V$, где δV — ширина области роста тока вблизи энергетич. щели, предельное значение от-

клика соответствует квантовому пределу h/e . Пороговая чувствительность R_d такого детектора ограничивается шумом тока смещения. В квантовом пределе R_d пропорциональна корню квадратному из числа фотонов, поглощённых за время, соответствующее обратной ширине полосы детектора, и вызывающих изменение тока в детекторе, равное ср. шумовому току. Достигнутое значение $R_d = 2,6 \cdot 10^{-16}$ Вт/ГГц^{1/2} для частоты 36 ГГц очень близко к квантовому пределу и является наилучшим для детекторов миллиметрового диапазона. В комбинахров. туннельном переходе сверхпроводник — изолятор — нормальный металл было осуществлено детектирование излучения с частотами до ≈ 600 ГГц, величина отклика при этом также была близка к квантовому пределу.

Резкая нелинейность ВАХ переходов СИС используется для создания смесителей миллиметрового диапазона. Первоначально СИС использовались только как нелинейное сопротивление по схеме обычного классич. смесителя. В этом режиме для туннельного перехода Рb(Vi) были получены малые потери преобразования (≈ 2 дБ), а шумовая темп-ра 3 ± 4 К (на частоте ≈ 36 ГГц). Позднее теоретически и экспериментально было показано, что в результате происходящего в СИС процесса туннелирования, сопровождаемого поглощением фотонов падающего излучения, $hf > \delta V$, выходной импеданс может принимать очень большие значения и даже становиться отрицательным. Подобные эффекты наблюдаются при смещении, несколько меньшем $2\Delta/e$, и в этом случае преобразование сигнала может осуществляться с большим усилением. Реализация больших усилений на практике приводит к неустойчивой работе приёмника. Поэтому наиб. выгодным оказался режим работы с таким усилением, при к-ром шумовая темп-ра усилителя промежуточной частоты, рассчитанная к смесителю, соответствует уровню шумовой темп-ры смесителя T_N . В таком режиме на оловянном СИС с круглой ВАХ при усилении ≈ 4 дБ удалось достичь значений $T_N = 9 \pm 6$ К для частоты 36 ГГц. Смесители на основе СИС получили довольно широкое распространение и на практике применяются разл. варианты их конструкций. Частотная область их использования $30\text{--}300$ ГГц. Значение T_N близко к квантовому пределу h/k и по этому параметру СИС-смесители превосходят и смесители на основе диозефовских переходов и на основе эффекта Шоттки. По своей чувствительности они достигли уровня *мазеров*, будучи вместе с тем более высокочастотными и широкополосными, чем последние. Частотный диапазон СИС-смесителей со стороны высоких частот ограничивается шунтирующим действием собств. ёмкости перехода и возрастанием вклада доплыв. (диозефовского) шума с увеличением частоты. Для повышения рабочих частот перспективным является использование сверхпроводящих материалов с высокой критической температурой.

Высокая чувствительность описанных выше С. п. в ряде случаев близкая к квантовому пределу, делает целесообразным их применение прежде всего для регистрации чрезвычайно слабых потоков эл.-магн. излучения — в спектроскопии, астрономии, биологии, медицине и во многих физ. измерениях.

Лит.: Надь Ф. Я. Приёмники миллиметрового и субмиллиметрового излучения на основе диозефовских переходов, «ПТЭ», 1975, № 1, с. 7; Кошелев В. П., Овсянников Г. А., Кривошеин СВЧ устройства, «Зарубежная радиоэлектроника», 1982, № 8, с. 31; Хребтов И. А., Сверхпроводниковые болометры, «ПТЭ», 1984, № 4, с. 5; Tucker J. R., Feldman M. J., Quantum detection at millimeter wavelengths, «Rev. Mod. Phys.», 1985, v. 57, № 4, p. 1055.

Ф. Я. Надь.

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ МАГНИТ — *электромagnet*, в к-ром ток, создающий магн. поле, протекает в осв. по сверхпроводнику, вследствие чего омические потери в обмотке С. м. весьма малы. С. м. намагниот сверхпроводящим проводом, состоящим, как правило, из волокон сверхпроводящего материала (напр., сплава

вниобия с титаном или соединения типа $A-15: Nb_2Sn, V_3Ga$), заключённых в матрице из несверхпроводящего металла. Обмотку С. м. помещают в *криостат*, поддерживающий темп-ру ниже темп-ры перехода проводов обмотки в сверхпроводящее состояние. Ведутся работы над созданием С. м. с использованием высокотемпературных сверхпроводников, открытых в 1986 г. м. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*).

Параметры С. м. принципиально ограничены свойствами сверхпроводящего провода: значением его критич. темп-ры, *критическим магнитным полем* и токо-несущей способностью (*критическим током*). Инобий-титановые С. м. позволяют получать при 4,2 К магн. индукцию $B \lesssim 10$ Тл, а ниобий-оловянные С. м. — $B \lesssim 20$ Тл. Первонач. попытки применить в С. м. сверхпроводники 1-го рода [Х. Камерлинг-Оннес (Н. Kamerlingh-Onnes), 1911] оказались неудачными из-за низких значений критич. магн. полей этих материалов. Первые С. м. на совр. материалах (из т. н. жестких сверхпроводников 2-го рода) были созданы в 1961.

Достоинством С. м. по сравнению с обычными резистивными электромагнитами является малое потребление энергии, в осн. на компенсацию теплоты, поступающей через теплоизоляцию криостата, по несверхпроводящим тоководам, а также на тепловыделение в омических контактах между отрезками сверхпроводящих проводов. В С. м. с пост. индукцией расход энергии по крайней мере в тысячу раз меньше, чем омические потери в резистивных обмотках обычных электромагнитов такого же назначения. Капитальные затраты на создание крупных С. м. сопоставимы с затратами на создание резистивных электромагнитов — относительно высокая стоимость сверхпроводящей обмотки компенсируется отсутствием необходимости в мощных источниках питания и громоздких системах её водяного охлаждения. Макс. размеры С. м. ограничиваются не энергетич. соображениями, а прочностью материалов, из к-рых изготовляют багдаж С. м. Существуют проекты С. м. с характерными размерами до деск. сотен метров.

Рабочая темп-ра совр. С. м. лежит в диапазоне 1,8—10 К, хладагентом служит жидкий или газообразный гелий. Большинство С. м. работает в криостатах, заполненных жидким гелием, кипящим при атмосферном или пониженном давлении. Иногда применяют косвенное охлаждение обмотки, при к-ром теплопроводность вещества (компаунда), пропитывающего обмотку, позволяет отвести от неё теплоту к конструктивным элементам, омываемым жидким гелием. В С. м. с заметным тепловыделением, обусловленным либо гистерезисными и кооперативными потерями в сверхпроводящем проводе в переменном магн. поле, либо радиац. потерями, применяют проточное охлаждение, создавая принудит. движение хладагента через обмотку. В особо крупных С. м. и в С. м. сложной конфигурации нередко используют циркуляц. охлаждение, направляя поток хладагента по герметичному каналу, совмещённому с обмоточным проводом.

Специфич. недостатком С. м. является возможность его выхода из рабочего режима вследствие потери обмоткой сверхпроводимости, причём это может произойти при значениях тока, существенно меньших токо-несущей способности провода (даже при значениях индукции и темп-ры, соответствующих расчётным рабочим параметрам С. м.). Это явление наз. дегр. ад. в *сверхпроводящего провода* в обмотке С. м. Переход обмотки С. м. в нормальное (несверхпроводящее) состояние сопровождается диссипацией запасённой эл.-магн. энергии, разогревом обмотки и возникновением внутри неё значит. электрич. напряжений, что может повести к повреждению С. м. Физ. природа деградации связана с тем, что в напряжённой полдероторными силами обмотки С. м. происходит микрособытия (возмущения), сопровождающиеся тепловыделением

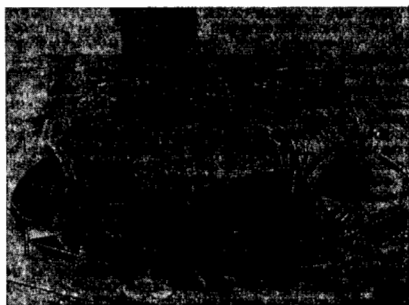
(движение витков, растрескивание компаунда, проскальзывание обмотки относительно каркаса), к-рые могут привести к превышению критич. темп-ры в захваченном этим возмущением объёме провода. Величина и вероятность таких возмущений пока не поддаются расчёту, но их естественно связать с уровнем достигаемых в обмотке механч. напряжений, что позволяет объяснить тот эмпирич. факт, что деградации в большей степени подвержены крупные С. м. с П. м. некрутой формы. Механич. возмущения, амплитуда к-рых недостаточна для перевода сверхпроводника в норм. состояние непосредственно, могут спровоцировать т. н. термоматгн. неустойчивость и привести к деградации. В процессе развития неустойчивости выделяется дополнит. энергия, запасённая в токах, экранирующих сверхпроводящий провод, когда он находится во внем. магн. поле. Эта энергия тем больше, чем больше диаметр сверхпроводящих волокон и их критич. ток, поэтому обмотки из проводов с толстыми волокнами и из проводов с высокой токо-несущей способностью более подвержены деградации. В С. м. с медленно изменяющимся магн. полем, таким, что возникающее электрич. поле в виде в провода не превышает электрч. поля срыва» (0,1—10 мВ/см), термоматгн. неустойчивость не развивается самопроизвольно и для перевода провода в норм. состояние необходимо внеш. возмущение конечной величины. В обмотках с быстро меняющимся полем возможно спонтанное развитие термоматгн. неустойчивостей.

Увеличение или уменьшение норм. зоны, возникшей в обмотке под влиянием возмущения, зависит от баланса выделения в этой зоне тепла и теплообмена в обмотке. Несверхпроводящая зона может исчезнуть, и при этом режим С. м. не нарушится, а может и распространиться по обмотке. Защита С. м. в этом случае заключается в уменьшении тока в обмотке со скоростью, позволяющей не допустить чрезмерного перегрева обмоточного провода и слишком быстрого испарения жидкого гелия, но и не столь большой, чтобы растущие в обмотке электрч. напряжения могли повредить изоляцию провода.

Выбор способа защиты обмотки при переходе её в норм. состояние зависит от скорости распространения в ней норм. зоны. В С. м., в к-рых эта скорость мала, применяют активную защиту: отключив источник питания, представляют току возможность затухнуть на сопротивлениях, расположенном вне криостата. При невозможности применения активной защиты стараются искусственно увеличить скорость распространения норм. зоны, чтобы запасённая энергия выделилась в обмотке возможно равномернее и не привела к локальным перегревам.

Меры борьбы с деградацией заключаются в уменьшении частоты и амплитуды механч. возмущений (для этого закрепляют провод по всей длине обмотки). Саму обмотку делают возможно более жёсткой и ограничивают возможности развития термоматгн. неустойчивости, используя обмоточные провода с весьма тонкими сверхпроводящими волокнами (0,1—30 мкм), скрученными вокруг продольной оси. Повышают также устойчивость к возмущениям и обеспечивают условия для исчезновения в проводе норм. зоны, если она возникла (для этого в сечении провода увеличивают долю норм. металла с высокой электропроводностью, повышают эфф. теплоёмкость провода и улучшают его теплообмен с жидким гелием). При обеспечении отвода к хладагенту практически всего тепла, генерируемого при рабочем токе в проводе, нагревом до критич. темп-ры, возникшая норм. зона неизбежно исчезает. Такие стационарные стабилизаторы обмотки наиб. надёжны, но этот метод используют лишь в особо крупных С. м., поскольку требуются кол-во норм. металла и значит. сечение необходимых для хладагента каналов резко снижают ср. плотность тока в обмотке (до $3—10 \cdot 10^7$ А/м²), делая её весьма громоздкой. Не-

обязательное осуществление хорошего теплообмена в обмотках, где возмущения ограничены, позволяет достигать в них высоких ср. плотностей тока ($2-5 \cdot 10^8$ А/м²). Однако обычно эти значения заметно меньше критич. плотности тока в сверхпроводнике. Выбираемая при проектировании С. м. ср. плотность тока зависит от значений запасной в обмотке энергии, требований к надежности С. м., а также от макс. индукции в обмотке. В С. м., рассчитываемых на получение



Внешний вид сверхпроводящего магнита установки «Токам Т-15» Института атомной энергии имени И. В. Курчатова (Москва, 1988).

сильных магн. полей, при к-рых плотность тока в ирреводе ограничивается макс. значением индукции в обмотке, ср. плотность тока можно повысить за счёт применения проводов равных сечений (большого в области с высокой индукцией и меньшего в областях с низкой индукцией). Такая оптимизация сечения проводов обмотки позволяет увеличить ср. плотность тока в неск. раз по сравнению с локальной плотностью тока в области макс. индукции.

С. м. нашли широкое применение в науч. приборостроении. Сверхпроводящие соленоиды с индукцией до 15–16 Тл используются для исследований в физике твёрдого тела и для испытаний сверхпроводящих материалов. Для ЯМР-спектрометров используют высокостабильные С. м. с короткозамкнутой обмоткой и характерным временем изменения магн. поля до 10^{10} с. С. м. в физике высоких энергий служат в качестве отклоняющих, фокусирующих и анализирующих магнитов (см. *Детекторы*), напр.: ускоритель с энергией протонов до 0,8 ТэВ в Лаборатории им. Ферми (США); сооружаемый в пос. Протвино под Москвой ускоритель-накопитель комплекс с энергией протонов до 3–5 ТэВ; пузырьковая камера объёмом 33,5 м³ в С. м. к-рой запасена энергия 800 МДж (ЦЕРН, Швейцария). Особо крупные С. м. применяют в физике плазмы и в прототипах термоядерных реакторов. Введённая в 1989 в СССР (Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова) установка «Токам Т-15» имеет тороидальный С. м. с запасом энергии 0,5–1 ГДж (рис.). ЯМР-томографы с С. м. используют в медицине.

Существует много идей по применению С. м. в народном хозяйстве: сверхпроводящие обмотки возбуждения электр. машины и МГД-генераторов, поезда на магн. подушке, энергетич. накопители, магн. сепараторы для обогащения слабых магн. руд. Однако внедрение низкотемпературных С. м. встречает большие трудности. Освоение высокотемпературной сверхпроводимости должно снять многие технич. трудности по применению С. м.

Лит.: Сверхпроводящие соленоиды. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1985; Техническая сверхпроводимость в электроэнергетике и электротехнике. Сб., М., 1982; Уилсон М., Сверхпроводя-

щие магниты, пер. с англ., М., 1985; Collins E. W., Applied superconductivity, metallurgy and physics of titanium alloys, v. 1–2, N. Y.—L., 1986.

Е. Ю. Кашинко, А. В. Попов

СВЕРХРЕФРАКЦИЯ — явление инверсии высотного хода приведённого (с учётом сферичности земной поверхности) показателя преломления для радиоволн, распространяющихся над поверхностью Земли (см. также *Рефракция радиоволн*). Приводит к образованию тропосферного волновода для УКВ и к существу. расширению радиогоризонта.

Лит.: Фок В. А., Проблемы дифракции и распространения электромагнитных волн, М., 1970; Крайцов Ю. А., Фейзулин З. И., Виноградов А. Г., Прокоевский радиоволн через атмосферу Земли, М., 1983.

А. В. Попов

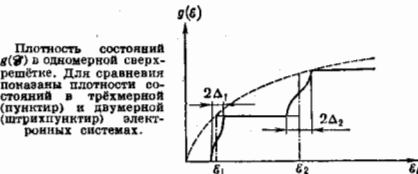
СВЕРХРЕШЕТКА — твёрдотельная периодич. структура, в к-рой на носители заряда (электроны), помимо обычного потенциала кристаллич. решётки (см. *Внутрикристаллическое поле*), действует дополнит. потенциал. Как правило, это одномерный потенциал $V(r)$ с периодом d , меньшим длины свободного пробега электронов, но значительно большим периода a осей решётки (от нескольких нм до десятков нм). Наиб. интенсивно исследуются полупроводниковые С., во наряду с ними возможны металлич. и магн. С. Потенциал $V(r)$ обычно создается искусственно путём чередования тонких полупроводниковых слоёв, отличающихся по типу легирования и (или) хим. составу (композиционные С., *гетероструктуры*). В последнем случае С. можно рассматривать как периодич. систему квантовых ям, разделённых сравнительно узкими барьерными слоями с заметной туннельной прозрачностью для носителей заряда (волновые ф-ции электронов перекрываются).

Если длина свободного пробега носителей существенно превосходит период потенциала $V(r)$, то наличие последнего видоизменяет энергетич. спектр электронов и дырок. Дополнит. периодичность вдоль одной из осей (z), наа. о сью С., приводит к тому, что компонента энергетич. спектра, связанная с движением вдоль этой оси, представляет систему узких полос — m и n и z ои. В перпендикулярной плоскости носители ведут себя как свободные частицы с соответствующей эфф. массой m . Полностью энергетич. спектр носителей заряда в С. может быть записан в виде

$$E = E_i + \Delta_i \cos(p_z d / \hbar) + \left(p_x^2 + p_y^2 \right) / 2m,$$

где i — номер минизоны, Δ_i — её ширина.

На рис. показан вид *плотности состояний* $g(E)$, соответствующей такому спектру. Значения Δ_i и E_i (определяющей положение минизоны) зависят от амплитуды и формы $V(z)$. С ростом амплитуды $V(z)$ и её периода d ширина минизоны Δ_i уменьшается. При узких минизонах ($\Delta_i \ll kT$) волновые ф-ции электронов



вдоль осей z перекрываются незначительно (прозрачность барьеров мала) и электронный спектр состоит из дискретных уровней (узких энергетич. рассеяний). Носители заряда в С. локализованы в ямах потенциала $V(z)$, и $g(E)$ имеет вид ступенки. Электронный газ

в С. ведёт себя как двумерный. Напротив, при $\Delta_1 \gg \Delta T$ свойства С. схожи со свойствами трёхмерного полупроводника.

Для С. характерна рекая анизотропия важнейших электронных свойств, в первую очередь кинетик. коэффициентов и внутриволновых оптич. характеристик, где полосы интенсивного межмашионного поглощения существуют лишь для света, поляризованного вдоль оси С. Последнее обстоятельство позволяет использовать С. в качестве фильтров и поляризаторов ИК-излучения. Эффекты межмашионного поглощения находят применение в ИК-фосфорильмаках с диапазоном спектральной чувствительности, зависящим от параметров потенциала $V(r)$.

Из-за малой ширины мишион нелинейные эффекты в проводимости вдоль оси С. проявляются при значительно меньших напряжениях электрич. поля, чем в однородных кристаллах. Это позволяет использовать С. для нелинейного преобразования СВЧ-сигналов (генерация высших гармоник и комбинац. частот, самоволнуиров. прозрачность и др.). В пост. электрич. поле, параллельном оси С., вольт-амперная характеристика (ВАХ) имеет падающие *N*-образные участки. Благодаря их наличию С. можно использовать в качестве генератора и усилителя эл.-магн. колебаний, частота к-рых может перестраиваться в широких пределах изменением электрич. поля. Суперрешётчатые гетероструктуры находят применение также в лавинных фотодиодах. Благодаря различию в разрывах зоны проводимости и валентной зоны на гетерогранице, коэффициенты умножения электронов и дырок могут резко различаться, что способствует снижению шумов при лавинном умножении.

Интерес представляют также т. н. *nipi*-суперрешётки — химически однородные полупроводники с чередующимися *n*- и *p*-слоями, напр. в $n\text{-GaAs}-i\text{-GaAs}-p\text{-GaAs}$. В них амплитуда потенциала $V(r)$, определяющая эфф. ширину запрещённой зоны, спектры фоточувствительности и люминесценции, а также ряд др. свойств могут меняться в широких пределах под влиянием внеш. подсветки или управляющего напряжения между *n*- и *p*-слоями.

Для изготовления С. на основе гетероструктур чаще всего используется система $\text{GaAs}-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ с хорошо согласующимися постоянными решётки. Однако последнее требование не является обязательным, существуют т. н. *n* и *p* а р ж ё н н ы е С., где рассогласование решётки ликвидируется за счёт внутр. напряжений в слоях. Указанные напряжения, величина к-рых зависит от толщины слоёв, могут заметно изменять параметры энергетич. спектра С. (напр., ширину запрещённой зоны). Это открывает дополни. возможность управления спектром фоточувствительности и нек-рыми др. свойствами. Важнейшие материалы для изготовления напряжённых С. — твёрдые растворы $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$, $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$, $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ и др. Для приближенио дальнего ИК-излучения используются С. в системе $\text{CdTe}-\text{HgTe}$, успешно заменяющие однородные твёрдые растворы в той же системе. Осн. методом вырашивания как гетероструктурных, так в *nipi*-С. служит молекулярно-лучевая эпитаксия.

Возможны также плоские С., к-рые возникают, если в двумерном электронном слое (напр., в *MDEP-структурах*) периодические промодулировать плотность поверхностного заряда. В качестве С. для двумерных электронов может также использоваться поверхность с выноками кристаллографич. индексами (орн и т а ц и о н н а я С.). Наряду с такими статическими С. возможны также динамические С., создаваемые периодич. деформацией образца в поле мощной УЗ-волны или стоячей световой волны.

Помимо искусственных С., существуют естественные С. в виде полугетных полупроводниковых соединений, напр. SiC , слоистых полупроводников типа $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{VI}}$

(напр., GaSe), дихалькогенидов переходных металлов (напр., MoS_2 , см. *Суперструктура*).

Лит.: Дин А. Я., Суперрешётки периодические полупроводниковой структуры (Обзор), «ФТТ», 1974, т. 8, в. 10, с. 1841; Озбогун Г. С., Strained-layer superlattices from lattice mismatched materials, *J. Appl. Phys.*, 1982, в. 53, р. 1586; Си Ли и А. П., Полупроводниковые суперрешетки, «ЭФН», 1985, т. 14, в. 2, с. 487; Васс Ф. Г., Булгаков А. А., Теретов А. П., Высококачественные свойства полупроводников со суперрешетками, М., 1989; Херман М., Полупроводниковые суперрешетки, пер. с англ., М., 1989; Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры, пер. с англ., М., 1989. А. Я. Шил.

СВЕРХСВЕТОВАЯ СКОРОСТЬ — скорость, превышающая скорость света. Согласно относительности теории, передача любых сигналов и движение материальных тел не может происходить со скоростью, большей скорости света в вакууме. Однако всякий колебат. процесс характеризуется двумя разл. скоростями распространения: групповой скоростью $u_{\text{гр}} = \partial\omega/\partial k$ и фазовой скоростью $u_{\text{фаз}} = \omega/k$, где ω и k — частота и волновой вектор волны. $u_{\text{гр}}$ определяет скорость переноса энергии группой волн с близкими частотами. Поэтому в соответствии с принципом относительности $u_{\text{гр}}$ любого колебат. процесса не может превышать c . Напротив, $u_{\text{фаз}}$ к-рая характеризует скорость распространения фаз каждой монохроматич. составляющей этой группы волн, не связана с переносом энергии в волне. Поэтому она может принимать любые значения, в частности и значения $> c$. В последнем случае о ней говорят как о С. с.

Простейший пример С. с. — фазовая скорость распространения эл.-магн. волн в волноводах. Действительно, эл.-магн. волна частоты ω распространяется вдоль оси волновода по закону $\exp[i(k_2 z - \omega t)]$, где k_2 — проекция волнового вектора k на ось волновода *z*. Волновой вектор k связан с частотой ω соотношением $k^2 = \omega^2/c^2$, где $k^2 = k_x^2 + k_z^2$, а k_1 — проекция волнового вектора k на поперечное сечение волновода *x* и *y* осей. Тогда $u_{\text{фаз}}$ волны вдоль осей волновода

$$u_{\text{фаз}} = \omega/k_z = c / \sqrt{1 - c^2 k_1^2 / \omega^2}$$

будет больше c , а

$$u_{\text{гр}} = \partial\omega/\partial k_z = c \sqrt{1 - c^2 k_1^2 / \omega^2}$$

меньше c .

Приведём ещё один пример существования С. с. Если вращать электронный пучок с помощью соответствующей электронной пушки вокруг нек-рой оси с угл. скоростью Ω , то линейная скорость пятна от пучка электронов $u = \Omega R$ на достаточно больших расстояниях R от осн может стать больше скорости света. Однако перемещение электронного пятна от пушки по окружности радиуса R_0 со скоростью $u = \Omega R_0 < c$ эквивалентно перемещению в пространстве фазы пучка. Энергия пучка при этом переносится в радиальном направлении и скорость переноса не может стать больше c .

При распространении сигнала в среде с показателем преломления n волновой вектор k эл.-магн. волны и её частота удовлетворяют соотношению $k^2 = (\omega^2/c^2)/n^2$. В этом случае $u_{\text{фаз}} = c/n$. Для среды с $n < 1$ $u_{\text{фаз}} > c$. Пример такой среды — полностью ионизованная плазма, у к-рой $n^2 = 1 - 4\pi N e^2/m\omega^2$, где e и m — заряд и масса электрона, а N — плотность электронов в плазме. В среде с $n > 1$ $u_{\text{фаз}} = c/n < c$. Однако в этом случае возможно реальное движение материальных частиц со скоростью v , большей скорости света в среде (т. е. $v > c/n$). Движение заряд. частиц с такой скоростью ($v > c/n$, но $v < c$) приводит к возникновению Черенковской — Вавилова излучения.

Лит.: Вавилов С. Я., Дин А., Электромагнитные волны, 2 изд., М., 1988; Гинзбург В. Л., Теоретическая физика и астрофизика, 3 изд., М., 1987; Володарский Б. М., Высок В. П., Излучение при сверхсветовом движении зарядов, «ЭФН», 1980, т. 180, в. 6, с. 141. Ч. Н. Столяров.

СВЕРХСВЕТОВЫЕ СКОРОСТИ в астрофизике. Теория относительности предполагает существование макс. скорости движения физ. объектов (распространения сигналов), равной скорости света в вакууме. Однако изменение положения в пространстве точек, выделенных по тем или иным признакам, может происходить и с большими скоростями. Подобные же сверхсветовые движения нередко наблюдаются в активных *ядрах галактик*.

Краткая история их обнаружения такова. Известно, что *яркостная температура* $T_{\text{я}}$ некогерентных источников *синхротронного излучения* (в частности, радиосточников, связанных с вихревыми ядрами галактик) не может превышать теоретич. предел $\sim 10^{12}$ К. Большой темп-рам соответствует столь высокая плотность энергии синхротронного излучения, что происходит катастрофически быстрое потери энергии релятивистских электронов из-за обратного комптоновского рассеяния синхротронных фотонов (см. *Комптона эффект*). Однако наблюдения перем. вивгалактик, радиосточников часто дают $T_{\text{я}} > 10^{12}$ К, если их размеры d оценивать из очевидного соотношения $d \leq ct$, где t — характерное время перемещения (изменения потока излучения). (Непосредств. измерения размеров этих радиосточников, расположенных в ядрах галактик, невозможны из-за недостаточного угла разрешения обычных радиотелескопов.) Чтобы объяснить этот факт, предлагалось отказаться от некогерентного синхротронного механизма, к-рый успешно применялся для интерпретации остальных особенностей радиозлучения *квасаров и радиогалактик*. В 1966 М. Рис показал [1], что преодолеть указанное затруднение можно, если предположить, что излучающая плазма движется с релятивистской скоростью под небольшим углом к лучу зрения. Тогда наблюдаемая яркостная темп-ра может превышать собственую (в системе покоя плазмы) яркостную темп-ру в γ^3 раз, где γ — фактор Лоренца. Так возникла идея о выбросе вещества из ядер галактик с релятивистскими скоростями. В нач. 1970-х гг. М. Коэн, А. Мофсет (А. Moffet) и др. [2, 3] действительно обнаружили быстрые перемещения компонент ра-

диосточников. Причём проекция их линейной скорости на небесную сферу даже превышала скорость света. Благодаря развитию техн. базы и методов обработки данных *радиотелескопов* со сверххладными базами удалось построить качественные изображения радиосточников в ядрах галактик. На рис. 1(а, б) представлены карты (радиоаэрофото) радиосточников в ядре радиогалактики 3С120, полученные для двух разл. моментов времени [4]. (Расстояние в 2 мек дуги соответствует 1 парсеку $\approx 3 \cdot 10^{18}$ см.) Источник имеет типичную для ядер радиосточников структуру ядро — струя. Ядро — яркий точечный источник с координатами (0, 0); струю, имеющую здесь проекционный линейный размер ≈ 50 пк, удаётся проследить (с помощью др. радиотелескопов) вплоть до расстояний ≈ 100 пк, что гораздо больше размеров галактики. За тем она «вливается» в протяжённую компоненту радиосточника 3С120, т. е. радиооху. Полный размер радиосточника ≈ 400 пк, причём протяжённая структура содержит два «радиоуха», расположенные по разн. стороны от галактики. Сравнительное положение этих «пятен» на рис. 1(а, б), нетрудно заметить их смещение в сторону от ядра. Угл. скорость смещения $\approx 2,5$ мек дуги в год соответствует линейной скорости $\approx 4c$. Объяснение этого явления состоит в следующем. Рассмотрение нек-рое физ. образование, перемещающееся вдоль струи со скоростью $v_{\text{пл}}$ под углом ϕ к лучу зрения (рис. 2). Проекция его скорости на небесную сферу $v_{\text{пр}} = v_{\text{пл}} \sin \phi$. Однако чем дальше оно продвигается вдоль струи, тем меньше времени требуется испущенным им фотонам, чтобы достигнуть наблюдателя. Из-за этого наблюдаемая скорость перемещения пятна в картинной плоскости

$$v_{\text{наб}} = \frac{v_{\text{пр}} \sin \phi}{1 - v_{\text{пл}} \cos \phi/c}$$

На рис. 3 представлена зависимость $v_{\text{наб}}$ от ϕ при разл. значениях $v_{\text{пл}}$. Видно, что при релятивистских значениях $v_{\text{пл}}$ наблюдаемая скорость $v_{\text{наб}}$ может превышать c .

Т. о., и высокие яркостные темп-ры, и «сверхсветовые» перемещения «пятен» можно объяснить, если радиозлучающая плазма выбрасывается из ядра галактики с релятивистскими скоростями. Другое важное свойство, имеющее естеств. объяснение в рамках такой интерпретации, — асимметрия ядерных радиосточников. Внеш. «радиоухи» с примерно одинаковыми характеристиками расположены по обе стороны от ядра галактики. А струя, к-рая, по совр. представлениям, обеспечивает их существование непрерывной передачей им энергии из ядра галактики, наблюдается лишь в направлении одного из них. (Такая асимметрия сохраняется и за пределами ядра.) Частота и излучат. способность (см. *Излучение плазмы*) в системе отсчёта наблюдателя ($v', v'_{\text{пл}}$) и в системе отсчёта движущейся (со скоростью V) плазмы струи ($v, v_{\text{пл}}$) связаны следующим обра-

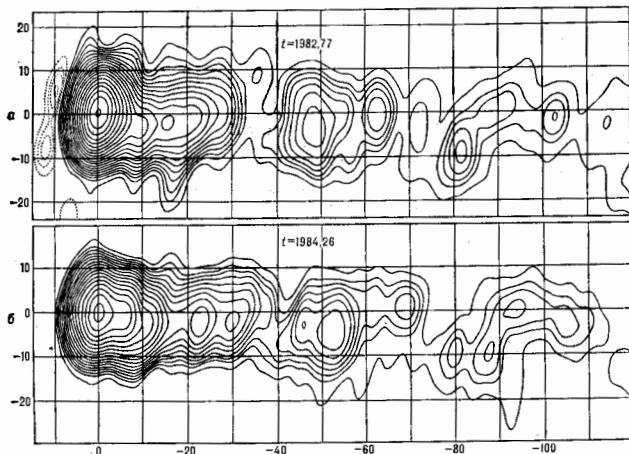


Рис. 1. Радиокарта источника 3С120: t — время в годах; АБ — расстояние от ярчайшей точки вдоль оси склонения в $0,001''$; Δz — расстояние от ярчайшей точки вдоль оси прямых восходящих в $0,001''$.

зом: $v = Dv'$, $e_s(v) = D^2 e_s(v')$, где $D = [\gamma(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{n})]^{-1}$ — фактор Доплера, \mathbf{n} — единичный вектор, направленный в точку наблюдения. Эти ф-лы отражают релятивистские эффекты смещения частоты и абберации излучения (см. *Доплера эффект*). Тогда при степенном законе $e_s(v') \propto (v')^{-\alpha}$ отношение потоков S от струй, вытекающих в противоположные стороны из ядра, равно:

$$\frac{S_+}{S_-} = \left(\frac{1 + v \cos \theta/c}{1 - v \cos \theta/c} \right)^{2+\alpha}$$

На рис. 4 показана зависимость этого отношения от θ при типичном значении $\alpha = 0.6$. Очевидно, что направленная к наблюдателю струя может быть гораздо ярче контрструи. Т. о., отмеченная асимметрия также объясняется релятивистскими эффектами. Успешное объяснение этих и др. свойств радиосточников в ядрах

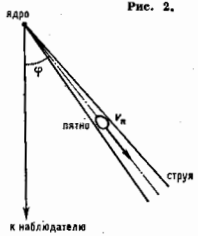


Рис. 2.



Рис. 3. Зависимость от θ наблюдаемой скорости движения «плотна» для различных значений фактора Лоренца пространственных перемещений $v_0 = 1/\sqrt{1 - (v_0/c)^2}$ ($v_0 = 2, 3, 4, 5, 6$; увеличивается снизу вверх).

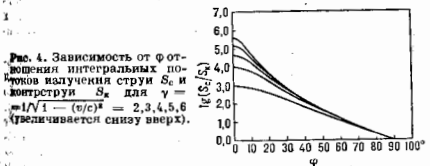


Рис. 4. Зависимость от θ отношения интегральных потоков излучения струй S_+ и контрструи S_- для $v = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0$ (увеличивается снизу вверх).

со стационарной ударной волной в этой струе, сверхсветовые «плотна» — с нестационарными ударными волнами. Повыш. яркость этих деталей объясняется процессами усиления магн. поля и ускорения релятивистских электронов на ударном фронте (см. *Ускорение заряженных частиц*).

СВЕРХСИЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ — поля с напряжённостью $H \geq 1$ Мэ (граница условия). Классификацию магн. поля обычно связывают со способами получения полей. Слабые (до 0,5 кэ) и средние (до 40 кэ) магн. поля получают в лаб. условиях с помощью постоянных магнитов и электромагнитов. Для получения сильных стационарных полей до ~300 кэ исполь-

зуют охлаждаемые и сверхпроводящие соленоиды (катюшки) (см. *Сверхпроводящий магнит*). Поля св. 300 кэ получают практически только в квазистационарных (длительность импульса $t \sim 10^{-3} \pm 10$ с) или импульсных ($t < 10^{-9}$ с) режимах при пропускании сильных электрич. токов через соленоиды разл. конструкций либо при сжатии внеш. силами магн. потока внутри замкнутого проводящего витка (д а й н е р а). Генерация С. м. п. с напряжённостью ≥ 1 Мэ сопровождается существом повреждениями материала катушек и даже их разрушением, т. е. магн. системы становятся пригодными только для однократного применения. Простейший способ получения С. м. п. — разряд батареи импульсных конденсаторов через одновитковый соленоид. Таким способом получают магн. поля до 8/Мэ. Поле в 4 Мэ обладает плотностью энергии $H^2/8\pi$, сравнимой с энергией связи атома в твёрдых телах ϵ (для металлов ϵ имеет величину неск. эВ/ат). В зоне действия такого поля происходит, как правило, полное разрушение (превращения в пар) материала катушки. Самые высокие значения поля (вплоть до 25 Мэ) в лаб. условиях получают методом сжатия магн. потока с использованием энергии взрывчатых веществ (ВВ).

Совр. физики интересуют и более высокие поля, недостижимые пока в лаб. практике, их влияние на строение атомов и молекул и соответственно на физ. свойства веществ. Оказывается, что существенных эффектов можно ожидать, напр., когда силы со стороны магн. поля $H_{ат}$ становятся преобладающими по сравнению с кулоновскими взаимодействиями электрона с ядром. Это происходит, когда величина поля $H > H_{ат} = m^2 e^2 c^3 / \hbar^2 = 2,35 \cdot 10^9$ Э. Ещё более сильное поле $H_{кв} = m^2 c^2 / e \hbar = 4,4 \cdot 10^{18}$ Э определяет границы применимости классич. *электродинамики*. В полях $H > H_{кв}$ значит. роль играют не только релятивистские, но и квантовые эффекты.

Астрофиз. исследования указывают на существование гигантских магн. полей у нек-рых типов звёзд (см. *Магнитные поля звёзд*). Напр., у *белых карликов* обнаружены поля $\sim 10^7$ Э, у *блуждающих нейтронных звёзд (пульсаров)* — 10^8 до 10^{12} Э. Ещё более высокие поля (10^{10} до 10^{18} Э) зарегистрированы у *рентгеновских пульсаров* — в двойных звёздных системах, одна из к-рых является нейтронной звездой. Сжатие магн. потока при гравитац. коллапсе звезды приводит к возникновению магн. полей 10^{14} Э. Эти уникальные природные источники открывают возможности для изучения С. м. п. такого уровня и их влияния на перестройку атомных структур, приводящую к появлению новых, необычных состояний вещества.

С. м. п., существующие в микромире, могут быть обнаружены при проведении нек-рых физ. экспериментов. Поля 10^8 до 10^9 Э имеются вблизи ядер свободных атомов, на что указывает *сверхтонкая структура* энергетич. уровней электронов (см. также *Внутримикроскопическое поле*). С. м. п. возникают при фокусировании мощных лазерных пучков. Напр., при фокусировке лазерного излучения плотностью $P = 10^{12}$ Вт на площади $S = 10^{-4}$ см² плотность ал.-магн. энергии P/cS в фокусе соответствует напряжённости поля $H = (8\pi P/cS)^{1/2}$, т. е. $\sim 10^9$ Э. Признаки существования магн. полей напряжённостью до 10^8 Э обнаружены при кумуляции плазмы в установках типа *лазерного фокуса*. Магн. поля звёздного уровня должны возникать при центральных столкновениях тяжёлых ионов. Эквивалентный электрич. ток ионов при таких взаимодействиях может возбуждать магн. поле $H = (Z_1 + Z_2) e_0 / 4\pi R^2$. При относительной скорости ионов $v = 0,1$ с и суммарном заряде $(Z_1 + Z_2) > 170$ на очень коротких расстояниях R , сравнимых с радиусом ядра, поле может достигать величин $\sim 10^{14}$ Э.

Получение сильных и сверхсильных магнитных полей. Задача получения сильных магн. полей в лаб.

практике сводятся к созданию источников тока и спец. устройств (соленоидов, катушек, лайнеров и др.), в к-рых и генерируется поле при прохождении через них тока. Источники тока и соленоиды должны удовлетворять техн. требованиям, соответствующим уровню получаемых полей. Т. к. $H \approx I$, то в общем случае увеличение поля в соленоиде требует соответствующего роста тока I . А это в свою очередь приводит к увеличению выделения джоулева тепла в материале соленоида и росту в нём механич. напряжений (за счёт мвгн. составляющей Лоренца силы). Поэтому осн. проблемы на пути продвижения в область более сильных полей связаны с решением задач тепловой стойкости и механич. прочности соленоидов.

Сильные стационарные магнитные поля получают в водоохлаждаемых резистивных системах, состоящих, как правило, из 2—3 коаксиальных соленоидов разл. конструкций. Максимально достигнутое поле в рабочем зазоре 32—50 мм составляет 250 кЭ (Институт физики твёрдого тела им. М. Планка, Гренобль, Франция). Ограничение величины поля связано с проблемой охлаждения обмоток соленоидов. Мощность P , рассеиваемая в катушке, связана с величиной поля H_0 в её центре соотношением

$$P = (r_{\text{вн}}/\lambda G) H_0^2$$

где $r_{\text{вн}}$ — внутр. радиус катушки, ρ — уд. сопротивление проводника, $\lambda = V_1/(V_1 + V_0)$ — коэф. заполнения (V_1 — объём проводника, V_0 — объём пространства в обмотке, незаполненный проводником), G — константа, характеризующая геометрию катушки. Чтобы получить, напр., поле $H = 100$ кЭ в медной катушке с $r_{\text{вн}} = 2$ см при комнатной темп-ре, нужен источник тока мощностью $P \approx 2$ МВт. Для получения магн. поля в 250 кЭ использовался источник с $P \approx 40$ МВт, а расход охлаждающей дистиллиров. воды составил ~ 400 м³/ч. В качестве одной из секций резистивных соленоидов часто используется конструкция катушки, предложенная Ф. Биттером (F. Bitter, 1939). В ней металлич.

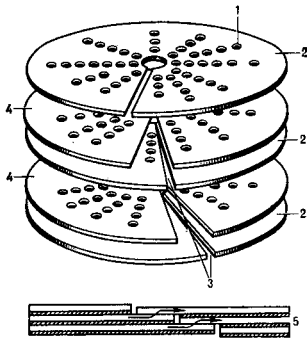


Рис. 1. Конструкция соленоида Биттера: 1 — охлаждающие отверстия; 2 — медные пластины; 3 — неизолированная поверхность контакта; 4 — изоляционные кольца; 5 — сечение катушки.

диски с разрезами, служащие витками соленоида, и изолирующие прокладки образуют при сборке двойную спираль, а охлаждающая вода прогоняется через перфорацию в дисках (рис. 1). Резистивные стационарные магниты с их системами питания и охлаждения представляют собой крупные дорогостоящие сооружения, ис-

пользующиеся во мн. науч. центрах. Дальнейшее повышение напряжённости стационарных полей в обычных резистивных системах ограничено техн. возможностями отвода больших мощностей, выделяющихся в малых объёмах. Кардинальное решение проблем теплового режима при генерации С. м. п. даёт использование сверхпроводящих материалов. Однако макс. поля, получаемые в сверхпроводящих соленоидах, не превышают 175 кЭ, хотя критические магнитные поля (H_c) некоторых сверхпроводников имеют большие значения (напр. $H_c \approx 250$ кЭ в Nb_3Ge , $H_c \approx 350$ кЭ в V_2Ga). Создание сверхпроводящих магн. систем с магн. полями > 175 кЭ затрудняется уменьшением с ростом поля критического тока и технол. проблемами.

Использование комбиниров. магн. систем, состоящих в одном устройстве резистивной и сверхпроводящей соленоидов, даёт перспективу получить стационарные магн. поля до 500 кЭ. В таких устройствах получено стационарное магн. поле напряжённости 318 кЭ (Национальная магнитная лаборатория им. Ф. Бит-

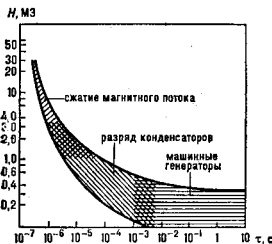


Рис. 2. Зависимость напряжённости магнитного поля от длительности импульса.

тера, США, 1987). Более высокие поля получают только в квазистационарном и импульсном режимах (рис. 2). Первые системы для получения таких сильных магн. полей были созданы П. Дж. Калпцей (1924).

Квазистационарными обычно наз. сильные магн. поля с длительностью импульсов поля ($\tau \sim 10^{-2} - 10$ с), при к-рой в соленоиде ещё слабо проявляется скин-эффект. Если напряжённость магн. поля при такой длительности импульсов не превышает 1 МЭ, его ещё можно получать в неразрушающихся системах. Для ограничения тепловыделения $q \sim I^2 r t \sim H^2 \rho t$ в материале катушки, растущего с повышением поля, используют два пути: уменьшение длительности импульса поля t и снижение уд. сопротивления ρ материала соленоида. (Предварительное охлаждение жёсткой обмотки соленоида до темп-ры жидкого азота [77,4 К] снижает её уд. сопротивление в 8 раз, а охлаждение до темп-ры жидкого водорода [20,4 К] — в 1000 раз.) При больших значениях поля мощность, выделяющаяся в обмотке соленоида, невозможно снять в течение импульса охлаждающей жидкостью и, чтобы не допустить опасного перегрева, нужно рассчитывать только на собств. теплоёмкость обмотки. При конструировании криогенных соленоидов необходимо учитывать, что с ростом поля и снижением темп-ры во мн. металлах (напр., у Си) линейно с полем растёт магнетосопротивление. В качестве материала для криогенных соленоидов часто используют алюминий высокой чистоты (99,999%), т. к. его магнетосопротивление при темп-рах 20—30 К стремится к насыщению уже в полях 20—40 кЭ. Помимо снижения электросопротивления глубокого охлаждения повышает механич. прочность материала соленоида, поэтому охлаждаемые катушки выдер-

живают большие напряженности поля. В полях ≈ 400 кЭ определяемое магн. полем давление $\sim H^2/8\pi$ создает в элементах конструкции соленоидов механич. напряжения, превосходящие предел текучести σ_0 большинства традиционно используемых для их изготовления материалов (Cu, разл. бронзы, Al и др.). Пондеромоторные силы стремятся разорвать витки обмотки соленоида в радиальном направлении и сжимают их в осевом, разрушая изоляцию. Уменьшением длительности импульса поля можно добиться того, чтобы материал обмотки не претерпел за время импульса знач. деформации. Квази стационарные соленоиды — многovitковые системы, обладающие, как правило, большим отношением собственной индуктивности к сопротивлению, и их легко согласовать с любыми используемыми источниками тока: конденсаторными батареями, мотор-генераторами, униполярными генераторами.

Существует большое кол-во конструкций квазистационарных соленоидов: однослойные и многослойные, секционированные, спиральные, часто используется конструкция биттеровского типа. Для повышения прочности конструкций применяют пропитку обмоток компаундами и используют наружные бандажки из прочной стали и композитных материалов. Рабочие объемы поля соленоидов колеблются от неск. см² до неск. сотен см², длительность импульсов у критических соленоидов, как правило, на $1 \div 2$ порядка выше, чем в тлиых. Ресурс соленоидов определяется не только механич. прочностью и тепловой стойкостью материала обмоток, но и качеством межвитковой эл. изоляции. Из-за накопления неизбежных остаточных деформаций в материале обмоток и изоляции в процессе работы соленоидов их ресурс ограничен и составляет от неск. импульсов при макс. полях до неск. тысяч импульсов.

В ряде конструкций предложены способы, облегчающие решение проблем механич. прочности соленоидов. В конструкции с самоподдерживающимися обмотками соленоид разбивается на секции, в каждой на х-рых механич. напряжения не превышают предела прочности материала и не чередуются от одной секции к другой. Суммарное воспроизводимое поле в таком соленоиде может быть ~ 1 МЭ. Однако при такой конструкции резко увеличиваются размеры и вес системы и снижается эффективность использования источника энергии (доли %). Для «бессильной» конфигурации обмоток векторы плотности тока j и поля H параллельны. В этом случае пондеромоторные силы $F \sim |jH|$, приводящие к механич. напряжениям в витках, обращаются в нуль (для бесконечных систем). Для реальных (конечных) обмоток можно добиться существ. уменьшения действующих сил в одной части магнита, а другая его часть будет «удерживать» (обжимать) первую. Такие «бессильные» конфигурации преобразуют высокое давление в малой области в низкое давление, распространенное на большую область, что приводит к увеличению размеров всей системы. Простейшая «бессильная» конфигурация представляет собой обмотку, навитую на цилиндр, каркас под углом 45° к образующей цилиндра. В такой системе наруж. азимутальное поле равно внутреннему аксиальному.

Сверхсильные импульсные магнитные поля получают чаще всего при разряде емкостных накопителей энергии на одновитковые соленоиды (рис. 3). Одновитковые катушки, разрушающиеся при однократном использовании, являются наиб. простой конструкцией для получения импульсных магн. полей в диапазоне $1 \div 4$ МЭ. Внутр. диаметр и длина катушек обычно не превышают 1 см. Индуктивность их мала ($L \sim \mu H$), поэтому для генерации в них сверхсильных полей требуются токи мегаамперного уровня. Их получают с помощью высоковольтных конденсаторных батарей с высокой собствен. индуктивностью и запасаемой энергией

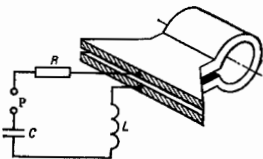


Рис. 3. Одновитковый соленоид, включенный в цепь конденсаторной батареи: С — конденсаторная батарея; Р — разрядник; R — сопротивление контура; L — внутренняя индуктивность контура.

$W \sim 10^4 \div 10^8$ Дж. Длительность импульсов получаемого поля $\tau \sim 10^{-6} \div 10^{-8}$ с, а время нарастания поля до макс. значения составляет обычно $0,5 \div 2$ мкс. Существ. роль в процессе генерации таких полей играет скин-эффект: ток концентрируется в тонком слое δ на внутр. поверхности соленоида. Плотность тока может достигать очень больших величин $j \geq 3 \cdot 10^7$ А/см². Следствием этого является возникновение в материале соленоида знач. градиентов температуры и магн. давления. Большие величины магн. давления $H^2/8\pi$, преобразующиеся в пределах глубины скин-слоя δ в механич. напряжение, инициируют ударно-волновое сжатие и пластич. течение материала соленоида за фронтом ударной волны. Из-за мощного энерговыделения $j^2 R$ в скин-слое растёт уд. сопротивление ρ , проникновение поля в материал соленоида приобретает нелинейный характер, токовый слой с внутр. поверхности перемещается в глубь проводника. Процесс нагрева носит адиабатич. характер. Темпер. поверхности в этом случае можно оценить по ф-ле $T = H^2/8\pi c_v \approx 3000 H^2$, где c_v — уд. теплоёмкость при пост. объёме, γ — плотность материала катушки (величина H выражена в МЭ). Уже при $H = 1$ МЭ поверхностный слой катушки, выполненный из тугоплавных металлов, начинает плавиться. С дальнейшим ростом поля область плавления распространяется в глубь проводника, а на его поверхности начинается испарение материала. «Волна испарения» проникает внутрь проводника, вследствие чего он теряет проводимость. Одновременно создаются условия для развития неустойчивостей на границе поле — проводник и эл. магн. пробоя слоя металла, паров, образующихся вблизи поверхности соленоида (характерные времена этих процессов сравнимы с длительностью импульса поля τ , а их интенсивность резко нарастает с увеличением H). В итоге происходит взрывообразное разрушение материала соленоида («взрыв скин-слоя»). За время τ возрастает размер обмотки, занимаемой полем в соленоиде, увеличиваются индуктивность и сопротивление соленоида. Это приводит к нарушению линейной зависимости между H и I (рис. 4) и простран-

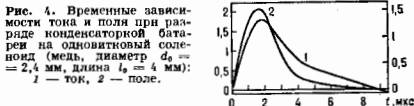


Рис. 4. Временные зависимости тока и поля при разряде конденсаторной батареи на одновитковый соленоид (мель, диаметр $d_0 = 2,4$ мм, длина $l_0 = 4$ мм): 1 — ток, 2 — поле.

венной нестационарности поля. При генерации мегаэрстедных импульсных полей ($H \sim 1 \div 4$ МЭ) осн. роль играют физ. процессы взаимодействия поля с материалом соленоида. Количеств. характеристики физ. процессов зависят не только от величины поля H , скорости его изменения dH/dt , τ , но и от физ. свойств материала соленоида и его размеров. По совокупности свойств лучше др. металлов противостоят разрушаю-

шему действию мезазерстного поля тантал. Это связано с высокой плотностью и темп-рой плавления Та, с характером распространения ударных волн (при к-ром обеспечивается малая скорость частиц), с высокой вязкостью, обеспечивающей целостность катушки при ударных нагрузках, и др. Разл. способы внеш. упрочнения конструкций импульсных соленоидов практически не оказывают влияния на величину генерируемого поля, т. к. за короткое время τ его существования возмущения из зоны взаимодействия поля с материалом катушек, где выделяется осн. энергия, не успевают распространяться на большой объём.

Метод сжатия магнитного потока (магн. кумуляция) позволяет получить макс. магн. поля в условиях лаборатории. Если внутри проводящей цилиндрич. оболочки (лайнера) с радиусом r_0 и сечением $S_0 = \pi r_0^2$ создать аксиальное магн. поле H_0 и затем симметрично и достаточно быстро сжать лайнер внеш. силами [за время t уменьшив радиус до $r(t)$], то магн. поток $\Phi = H_0 S_0$ внутри лайнера не успеет измениться и поле возрастёт: $H(t) = H_0 r_0^2 / r^2(t)$. Идея магн. кумуляции предложена А. Д. Сахаровым (1954) и реализована в виде устройств, получивших назв. магнитокумулятивных генераторов С. м. п. МК-1 (рис. 5). Сжатие лайнера

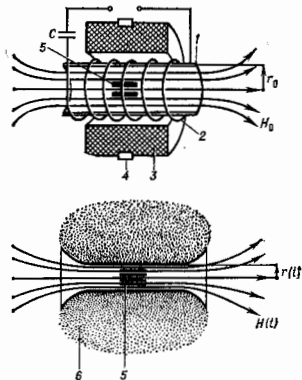


Рис. 5. Схема магнитокумулятивного генератора МК-1 сверхсильного магнитного поля: 1 — оболочка (лайнер); 2 — соленоид начального поля; 3 — заряд ВВ; 4 — детонатор; 5 — конденсатор; 6 — продукты взрыва.

осуществлялось давлением продуктов взрыва хим. ВВ. Источником тока для создания начального магн. поля может служить конденсаторная батарея или др. магнитокумулятивный генератор энергии (МК-2), используемый как импульсный генератор тока. В нём ал.-магн. импульсы генерируются при прямом преобразовании энергии взрыва в энергию поля в процессе сжатия и вытеснения магн. потока в нагрузку. В экспериментах были получены поля напряжённостью ок. 5 Мэ в попер. диам. 10 мм. В одном из опытов в полости диам. 4 мм удалось зарегистрировать рекордное поле 25 Мэ (1964). В аналогичном эксперименте в Лос-Аламосе (США) было получено поле ~ 15 Мэ. Однако неустойчивость магн. кумуляции являлась причиной невоспроизводимого характера генерации С. м. п. Возникающие неустойчивости связаны с развитием возмущений на границе поле — вещество и имеют ту же природу, что и в случае генерации мезазерстных полей в соленоидах.

Стабилизация процесса магн. кумуляции возможна при сжатии магн. потока системой последовательно включаемых коаксиальных оболочек (А. И. Павловский, ВНИИ экспериментальной физики, Арамас, 1980). Оболочки устроены так, что они свободно пропускают магн. поток, пока неодвижны, и захватывают его, когда начинают двигаться. Неподвижная оболочка (прошнмаемая для аксиального магн. потока) состоит из тонких изолированных друг от друга медных проводников. Под действием ударной волны сжатия, возникающей при столкновении движущейся оболочки с неподвижной, изоляция проводников разрушается. Образуется сплошная медная оболочка с изотропной проводимостью. Каждый раз, когда возникает угроза потери устойчивости разогретой внутр. границы оболочки, эта оболочка заменяется новой, холодной, к-рой передаются ф-ции дальнейшего сжатия потока. Такие устройства наз. каскадными генераторами С. м. п. (рис. 6). Их

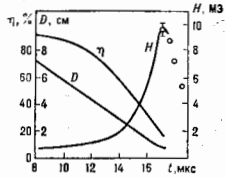


Рис. 6. Временные зависимости магнитного поля H , внутреннего диаметра D и коэффициента сжатия потока $\eta = \Phi_0/\Phi_0$ в трёхкаскадном магнитокумулятивном генераторе.

осн. достоинство заключается в том, что они обеспечивают стабильность работы и высокую воспроизводимость С. м. п. В каскадных генераторах устойчиво воспроизводятся поля напряжённостью до 16 Мэ в объёме ~ 5 см³. Плотность магн. энергии такого поля в 100 раз превышает плотность энергии хим. ВВ, а давление магн. поля достигает 10 Мбар.

Возможности каждого генератора (при использовании хим. ВВ) дают надежду на получение полей до 30 Мэ в объёме 1–5 см³, а при использовании энергии относительно небольшого ядерного взрыва — до 10³ Мэ.

Сжатие магн. потока, заключённого внутри цилиндрич. лайнера, может производиться также и электродинамич. силами, создаваемыми возрастающим магн. полем внеш. катушки. Расчёты показывают, что этот способ позволяет получать большие скорости радиального сжатия лайнера, и следовательно можно надеяться и на более высокие поля, чем при использовании ВВ. Практически в таких системах получены поля до 3,2 Мэ. Вследствие конечной проводимости материала лайнера часть магн. потока, создаваемого внеш. катушкой, может проникать на начальных стадиях ускорения внутрь лайнера, а затем сжиматься. Поэтому в системах с ал.-магн. сжатием можно обойтись без предварит. создания магн. потока внутри лайнера.

Применение сверхсильных магнитных полей. Начало использованию сильных магн. полей в физ. исследованиях было положено трудами П. Л. Капицы. В кон. 1920-х гг. он провёл в полях до 320 кЭ обширные исследования магнетосопротивления, намагнитченности, магнитострикции, Зеемана эффект, траекторий заряд. частиц. Макс. интерес вызывало С. м. п. в физике твёрдого тела. Они применяются в исследованиях гальваномагн., термомагн., оптич., магн.-оптич., резонансных явлений. Оптич. и магн.-оптич. исследования свойств мн. веществ проведены в полях до 10 Мэ, в т. ч. при низких темп-рах исследовано влияние С. м. п. на энергетич. спектры, зонную структуру и др. характеристики твёрдого тела. В полях до 2 Мэ исследованы спектры поглощения и циклотронный резонанс в полупроводниках, Фарадея эффект в видимой и ИК-облас-

тах спектра, зеемановское распределение спектральных линий, магнетоспротивление тонких висмутовых проволочек, проводятся исследования сверхпроводников с высокими критич. полями и др. В ядерной физике и физике элементарных частиц С. м. п. используются для идентификации частиц, фокусировки и отклонения зарядж. частиц, для генерации мощного тормозного излучения и т. д. С. м. п. широко применяются в исследованиях по физике плазмы и управлению термоядерным синтезу. Импульсное С. м. п. — источник для получения квазиадиабатич. давлений до 5 Мбар, в к-рых проводятся исследования ур-ния состояний ряда веществ, изучается сжатие твердого водорода при $T \approx 4 \div 6$ К. Энергия магн. поля напряженностью $\sim 10 \div 15$ МЭ превышает энергию связи частиц в твердых телах, магн. давление превышает давление в центре Земли. Такие поля используются для изучения свойств веществ в экстремальных условиях. Сильные магн. поля находят применение в химии, биологии, широко используются в технол. целях (напр., для магнитно-импульсной обработки и сварки металлов).

Измерения напряженности С. м. п. производятся прокалиброванными индукционными датчиками (магн. зондами), а также по величине эффекта Фарадея и эффекта Зеемана. В астрофиз. измерениях уровень С. м. п. оценивается по степени круговой поляризации непрерывного излучения.

Лит.: Сахаров А. Д., Вывымагнитные генераторы, *УФН*, 1966, т. 88, в. 4, с. 725; Техника больших импульсных токов и магнитных полей, М., 1970; Мольтомери Д. Б., Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов..., пер. с англ., М., 1971; Кнорпель Г., Сверхсильные импульсные магнитные поля, пер. с англ., М., 1972; Дилэути А. С., Ожиги В. И., Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте, М., 1988; Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применение, пер. с англ., М., 1988; Павловский А. И., Магнитная кумуляция, *Природа*, 1990, № 8, с. 29.

СВЕРХСТРУКТУРА — структура упорядоченного сплава, в к-рой атомы разного сорта правильно чередуются, образуя периодич. решётку с периодом, превышающим периоды кристаллич. решёток материалов, образующих сплав. Образование С. происходит ниже нек-рой темп-ры, называемой темп-рой упорядочения в тех случаях, когда атомам данного сорта энергетически выгоднее быть окружёнными атомами др. сорта. Часто С. возникает в результате фазового перехода 2-го рода. Примером С. может служить структура сплава Cu — Zn (β -латунь), где в неупорядоченном состоянии атомы Cu и Zn равномерно распределяются по узлам объёмноцентриров. решётки, а во вполне упорядоченном состоянии атомы одного сорта занимают узлы в верхних кубич. ячейк, а другого — в их центрах. Такого же типа С. встречается в сплавах состава, близкого к Cu — Be, Cu — Pd, Ag — Mg, Fe — Al, Au — Zn и др.

Лит.: Смирнов А. А., Молекулярно-кинетическая теория металлов, М., 1966.

СВЕРХТЕКУЧАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА — обобщение одночастичной оболочечной модели ядра, учитывающее парные корреляции нуклонов вблизи поверхности Ферми в средних и тяжёлых ядрах. С. м. я. опирается на понятие остаточного взаимодействия нуклонов. Согласно модели оболочек, значит. часть реального нуклон-нуклонного взаимодействия может быть учтена с помощью введения среднего, самосогласованного поля ядра, в к-ром нейтроны и протоны движутся почти независимо. Неучтённая часть нуклон-нуклонного взаимодействия — т. н. остаточное взаимодействие — чрезвычайно важна для понимания мн. свойств ядра. Если остаточное взаимодействие имеет характер притяжения, то оно существнейшим образом изменяет движение нуклонов вблизи поверхности Ферми, придавая ему коррелированный характер. Для двух взаимодействующих частиц с противоположными импульсами в направлениях спинов, находящихся у поверхности Ферми, принцип Паули ограничивает возможное взаимодействие. В результате оказывается, что трёхмерный потенциал для пары частиц у поверхности Ферми даже при

малом притяжении приводит к связанному состоянию.

В наиб. распространённых вариантах С. м. я. используется матем. аппарат теории *сверхпроводимости* (см. *Сверхтекучесть атомных ядер*). Теория С. м. я. разработана независимо С. Т. Бельевым, А. Б. Migdalом и В. Г. Соловьёвым. При этом в основе лежал либо метод *Боголюбова канонических преобразований*, либо ур-ния Л. П. Горькова в методе *Грина функций*.

В С. м. я. используется гамилтониан Бардина — Купера — Шриффера (БКШ). Применительно к ядру он имеет вид:

$$\mathcal{H}_{\text{вкш}} = \sum_{\lambda, \tau} \epsilon_{\lambda, \tau}^+ a_{\lambda, \tau}^- - \sum_{\tau, \lambda, \lambda'} G_{\tau, \lambda}^+ a_{\lambda, \tau}^+ a_{\lambda', \tau}^- a_{\lambda', \tau}^- \quad (1)$$

Здесь $\tau = p, r$ — т. н. изотопич. индекс (p — нейтроны, r — протоны), $a_{\lambda, \tau}^+$, $a_{\lambda, \tau}^-$ — операторы рождения и уничтожения нуклона сорта τ в состоянии λ с энергией $\epsilon_{\lambda, \tau}$; λ — состояние, отличающееся от λ знаком угл. момента нуклона; $G_{\text{пр}}$ — константа парного взаимодействия нейтронов или протонов. Знак второго слагаемого выбран так, что притяжение нуклонов отвечает $G > 0$. Гамильтониан не содержит взаимодействия нейтронов с протонами, эти подсистемы выступают в С. м. я. как независимые. Поэтому в дальнейшем рассматриваем нейтроны (для протонов результаты аналогичны).

Гамильтониан (1) приближённо диагонализуется с помощью линейного канонич. преобразования Боголюбова:

$$\begin{aligned} a_{\lambda}^+ &= u_{\lambda} \alpha_{\lambda}^+ - v_{\lambda} \alpha_{\lambda}^-, \\ a_{\lambda}^- &= u_{\lambda} \alpha_{\lambda}^- + v_{\lambda} \alpha_{\lambda}^+, \end{aligned} \quad (2)$$

где $u_{\lambda}^2 + v_{\lambda}^2 = 1$. Это преобразование трансформирует взаимодействующие частицы в неаλληствующее квазичастицы, представляющие собой суперпозицию нейтрона (протона) и нейтронной (протоновой) дырки. Т. к. операторы рождения и уничтожения квазичастиц являются линейными комбинациями аналогичных операторов частиц, то гамилтониан, диагональный в терминах квазичастиц, будет нарушать закон сохранения числа частиц. Для приближённого исправления этого дефекта переходят от (1) к всемог. гамилтониану $\mathcal{H}' = \mathcal{H} - \mu \hat{N}$, где \hat{N} — оператор числа частиц, а μ — множитель Лагранжа, имеющий смысл *химического потенциала*. Он определяется из условия $\langle \hat{N} \rangle = N$, где N — число частиц данного сорта.

Для приведения гамилтониана \mathcal{H}' к диагональному виду необходимо коэф. преобразования в ф-ле (2) выбрать в виде:

$$u_{\lambda} = \sqrt{1/2 + (\epsilon_{\lambda} - \mu)/2E_{\lambda}}, \quad (3)$$

$$v_{\lambda} = \sqrt{1/2 - (\epsilon_{\lambda} - \mu)/2E_{\lambda}},$$

$$E_{\lambda} = \sqrt{(\epsilon_{\lambda} - \mu)^2 + \Delta^2}. \quad (4)$$

Цель Δ и μ определяется из ур-ний

$$1 - G \sum_{\lambda} 1/E_{\lambda} = 0, \quad (5)$$

$$\sum_{\lambda} \frac{v_{\lambda}^2}{E_{\lambda}} = N. \quad (6)$$

При этом $\mathcal{H}'_{\text{вкш}}$ преобразуется в гамилтониан независимых квазичастиц, к-рый (с точностью до константы) имеет вид:

$$\chi' = \sum_{\lambda} E_{\lambda} \alpha_{\lambda} \quad (7)$$

с собств. значениями E_{λ} , α_{λ} к-рые определяют энергии квазичастиц возбуждений.

Ур-ние (5) в бесконечной системе имеет решение при сколь угодно слабом притяжении ($G > 0$). В конечной системе — ядре это так не так; величина G должна быть порядка расстояния между уровнями энергии нейтронов вблизи поверхности Ферми (с точностью до численных факторов, возникающих из-за суммирования по λ).

Макроскопич. подходы в теории ядра (метод Хартри — Фок — Боголюбова, теория конечных ферми-систем и др.) требуют уточнения соотношений (3) — (6) и точного учёта закона сохранения числа частиц. Однако все качеств. предсказания С. м. я. остаются в силе. Поэтому часто под С. м. я. понимают и более строгие теории, в к-рых последовательно учитываются нуклонная сверхтекучесть.

Лит. см. при ст. *Сверхтекучесть атомных ядер*.

Э. В. Сперштейн.

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ — явление бездиссипативного переноса массы в макроскопич. квантовых системах, находящихся в сверхтекучем состоянии; открыто в жидком ^4He (см. *Гелий жидкий*) П. Л. Капицей (1938) и в жидком ^3He Д. Ошероном, Р. Ричардсоном и Д. Ли (D. Osheroff, R. Richardson, D. Lee, 1972). Бездиссипативное (незатухающее) движение обеспечивается когерентностью фаз макроскопич. числа частиц квантовой жидкости (см. *Когерентное состояние*). Аналогична природа явления *сверхпроводимости*, а также явления спиновой сверхтекучести — бездиссипативного переноса намагниченности в сверхтекучем $^3\text{He-B}$.

Сверхтекучее состояние обладает дальним порядком (см. *Дальний и ближний порядок*) и возникает в квантовом статистич. ансамбле тождественных частиц в результате фазового перехода 2-го рода при охлаждении ниже темп-ры T_c перехода в сверхтекучее состояние. Для жидкого ^4He $T_c = 2,17$ К при давлении насыщенных паров, для жидкого ^3He $T_c = 2,7 \cdot 10^{-3}$ К при давлении 34 атм и $T_c = 0,9 \cdot 10^{-3}$ К при давлении насыщенных паров. Механизмы образования сверхтекучего состояния и вид его параметра порядка, отличного от нуля при $T < T_c$ и равного нулю при $T > T_c$, могут быть самыми разнообразными.

В жидком ^4He , состоящем из сферически симметричных атомов со спином $S = 0$, параметром порядка служит комплексная ф-ция $\psi = |\psi| \exp(i\varphi)$, имеющая смысл квантовомагнетизма, волновой ф-ции частиц, участвующих в когерентном движении. Состояния сверхтекучего ^4He с разл. значениями фазы хотя и имеют одинаковую энергию (вырождены), но не являются тождественными: между двумя связанными ансамблями с разными фазами φ_1 и φ_2 (напр., между сообщающимися сосудами с ^4He , соединёнными достаточно тонким каналом) возникает поток частиц $j \propto \sin(\varphi_1 - \varphi_2)$, зависящий от разности фаз $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ (аналог стационарного *Джозефсона эффекта*). Состояния с фазами, различающимися на $2\pi N$ (где N — целое число), обладающие одним и тем же значением параметра порядка $\psi = |\psi| \exp(i\varphi)$, эквивалентны. Т. о., имеется непрерывный набор вырожденных состояний, характеризующихся разл. значениями фазы φ от 0 до 2π . Тем самым произвол в выборе фазы, носитель название калибровочной симметрии или $U(1)$ -симметрии, в сверхтекучей жидкости отсутствует. Иными словами, С. является следствием нарушенной калибровочной симметрии (см. *Спонтанное нарушение симметрии*).

Если фаза φ зависит от координат, то в жидкости возникает когерентное сверхтекучее движение с локальной скоростью $v_s = (h/m)\nabla\varphi$, где m — масса атома ^4He . Скорость сверхтекучего движения (сверхтекучая скорость) в ^4He потенциальна (см. *Потенциальное течение*).

Для жидкости, принимающей участие в сверхтекучем движении, наз. сверхтекучей компонентой ρ_s . Плотность сверхтекучей компоненты ρ_s в жидком ^4He при $T = 0$ совпадает с полной плотностью жидкости ρ и уменьшается с повышением темп-ры до нуля при $T = T_c$. Значение ρ_s отлично от нуля только в сверхтекучем состоянии, поэтому часто комплексный параметр порядка ψ выбирают так, чтобы $|\psi|^2 = \rho_s$. Остальная часть жидкости с плотностью $\rho_n = \rho - \rho_s$ образует в нормальную компоненту n и ту, при низких темп-рах представляющую собой совокупность элементарных возбуждений (*квазичастиц*) двух типов — фононов и ротонов (см. *Ландау теория сверхтекучести*). Величина ρ_n при низких T определяется спектром элементарных возбуждений $\epsilon(p)$:

$$\rho_n = -\frac{1}{3} \int \frac{dn}{dv} p^3 \frac{d^2 n}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (1)$$

Здесь $n = n(\epsilon)$ — ф-ция распределения квазичастиц, p — импульс частицы. Отсутствие нормальной компоненты при $T = 0$ — следствие формы спектра элементарных возбуждений в ^4He . В принципе возможно и существование сверхтекучие системы ($^3\text{He-A}$, бесследные сверхпроводники, раствор ^3He в сверхтекучем ^4He) с ненулевой плотностью нормальной компоненты при $T = 0$.

Как и всякая обычная жидкость, нормальная компонента обладает вязкостью, обусловленной взаимодействием квазичастиц между собой. Нормальная компонента течёт со скоростью v_n , так что масса в сверхтекучем ^4He переносится с двумя скоростями: полный поток частиц $j = \rho_s v_s + \rho_n v_n$. Когерентное сверхтекучее движение не обладает *затрипией*. Всё тепловое движение в сверхтекучей жидкости связано с ϵ нормальной составляющей. Конвективный обратимый перенос *затрипии*, характерный для нормальных жидкостей, в сверхтекучей жидкости осуществляется нормальной компонентой со скоростью v_n и может происходить без переноса массы, т. е. при $j = \rho_s v_s + \rho_n v_n = 0$. Это приводит к существованию двух типов колебаний (звуков) в объёме сверхтекучего ^4He : помимо обычного звука — колебаний плотности и тона (т. е. первый звук), возможно распространение колебаний иного типа — *второго звука*, представляющего собой волны *затрипии*, или температурные волны (см. *Звук в сверхтекучем гелии*).

Двухскоростная гидродинамика Ландау, кроме ур-вий, содержащих обычные гидродинамич. переменные ($\rho, j, \text{затрипия } S$), включает ур-ние и для сверхтекучей скорости:

$$\partial v_s / \partial t = -\nabla \mu, \quad (2)$$

где μ — *химический потенциал*, выраженный через те же гидродинамич. переменные. Ур-ние (2) определяет осн. свойство сверхтекучего ^4He : для поддержания стационарного течения сверхтекучей компоненты не требуется разности хим. потенциалов на концах канала, т. е. сверхтекучее движение происходит без перепада давления. Иначе говоря, вязкость сверхтекучей компоненты равна нулю. Наличие разности хим. потенциалов ($\nabla \mu \neq 0$) приводит к ускорению сверхтекучей компоненты.

Отсутствие диссипации при стационарном течении сверхтекучей компоненты обнаруживается при наблюдении долгоживущего циркуляц. движения жидкости в кольцевом канале. В силу непрерывности параметра порядка фаза φ может измениться при обходе канала лишь на $2\pi N$, что приводит к квантованию циркуляц. сверхтекучей скорости $\int \rho_s dr = (h/m)N$. Тем самым всевозможные течения *забываются* в классы течений, характеризующиеся целочисленным квантумом N . Течения внутри одного класса с данным N могут непрерывно переходить друг в друга, а переходы между течениями разных классов требуют

появления разрывов в поле $\psi(r)$. Т. к. разрывам $\psi(r)$ соответствует бесконечный рост сверхтекучей скорости, то разрывы возможны, если в процессе перехода ρ_s обращается в нуль, т. е. в точках разрыва $\psi(r)$ сверхтекучее состояние разрушается. Последнее требует затрат энергии и создаёт шумовые потенциалы барьер между течениями с различными N , в результате чего циркуляция течения в неоднородном канале чрезвычайно устойчива. Существование целочисленного инварианта в сверхтекучем ^4He является следствием негравитационной топологии пространства вырождения R . В сверхтекучем ^4He R -область изменения фазы от 0 до 2π — окружность. В др. сверхтекучих жидкостях пространством вырождения может быть другим, при этом изменяется и классификация непрерывных течений в неоднородных каналах.

Независимость сверхтекучего и нормального движений в сверхтекучем ^4He имеет место только при достаточно малой разности скоростей $\mathbf{w} = \mathbf{v}_s - \mathbf{v}_n$. С увеличением w между её компонентами может возникнуть эфф. трение, препятствующее дальнейшему увеличению относительной скорости. В ^4He не имеется два механизма возникновения взаимного трения. Первый связан с тем, что начиная с нек-рой критич. скорости v_c наблюдается спонтанное рождение квазичастиц. Величина $v_c = \min\{c(p)/p\}$ в ^4He не составляет ≈ 60 м/с. Каждая родившаяся квазичастица увеличивает импульс $p_n v_n$ нормальной компоненты на величину p за счёт импульса $p_s v_s$ сверхтекучей компоненты, что приводит к взаимному трению. Изменение $p_s v_s$ в этом процессе происходит за счёт уменьшения p_s при сохранении v_s .

Второй механизм связан с рождением и движением топологич. объектов — квантованных вихрей (см. *Квантованные вихри в гелии*), представляющих собой особые линии, при обходе вокруг к-рых по замкнутому контуру фаза ψ изменяется на $2\pi N$, и следовательно циркуляция скорости v_s квантуется: $\oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{r} = (h/m)N$ [Л. Онсагер (L. Onsager), 1948]. На самой линии вихря фаза ψ не определена, поэтому для сохранения непрерывности параметра порядка ψ его модуль должен обращаться в нуль, т. е. S на оси вихря отсутствует. Область близки оси вихря, где значение $|\psi|$ отличается от равновесного, наз. с. е. р. д. в. и. и. о. или к. р. о. м. вихря. В сверхтекучем ^4He устойчивы вихри только с $N = \pm 1$, вихри с большим N распадаются на вихри с единичными квантами циркуляции сохранения N , напр. $2 \rightarrow 1 + 1$. Квантованные вихри испытывают трение со стороны нормальной компоненты благодаря рассеянию квазичастиц на коре вихря, поэтому в равновесии вихри движутся вместе с нормальной компонентой. Вихрь также является агентом, переносимым импульс между сверхтекучей и нормальной компонентами, но в отличие от квазичастичного механизма взаимного трения вихревой механизм приводит к изменению v_s : каждый вихрь, пореся канал, уменьшает или увеличивает набег (приток) фазы ψ в канале на 2π , изменяя тем самым v_s . Этот процесс, называемый проскальзыванием ψ фазы, может происходить в непрерывном (турбулентном) режиме и приводить к взаимному трению, если w превышает критич. скорость рождения вихрей $w_{cr} = (h/mR)\ln(R/\xi)$, где R — радиус канала, ξ — радиус ко-ры вихря, $R > \xi$. Для поддержания такого диссипативного движения сверхтекучей компоненты требуется разность давлений на концах канала. Ускорение сверхтекучей компоненты, вызываемое градиентом хим. потенциала, согласно ур-нию (2), компенсируется процессами проскальзывания фазы за счёт движущихся квантованных вихрей.

Наряду с турбулентным вихревым движением сверхтекучей компоненты наблюдаются и отд. процессы проскальзывания фазы при течениях сверхтекучей жидкости через узкое отверстие [О. Авенел, Э. Вароко (O. Avenel, E. Varoquaux), 1985], соединяющее два сообщаю-

щихся сосуда. Такой процесс квантованного изменения разности фаз $\Delta\psi = 2\pi N$, сопровождаемый скачками разности давлений, представляет собой аналог эффекта Джозефсона в сверхтекучей жидкости.

Квантованные вихри возникают не только как метастабильные образования в динамич. процессах сверхтекучего движения. Во вращающемся с угл. скоростью ω сосуде со сверхтекучей жидкостью периодич. решётка вихрей является осн. состоянием системы, аналогичным *рези́ке вихрей Абрикосова*, возникающей в сверхпроводниках 2-го рода в магн. поле. Это связано с тем, что во вращающемся сосуде минимум энергии системы соответствует твердотельному вращению всей жидкости со скоростью $v_n = v_s = |\omega r|$, т. е. $\text{rot} v_s = 2\omega$, но такое состояние не реализуется из-за потенциальности движения сверхтекучей компоненты в ^4He . Система параллельных квантованных вихрей с циркуляцией h/m в каждом вихре создаёт ср. завихренность $\langle \text{rot} v_s \rangle = (h/m)\pi$, где π — число вихрей на единице площади. В равновесии $\pi = 2(m/h)\omega$, и вихри имитируют твердотельное вращение сверхтекучей жидкости со ср. скоростью $\langle v_s \rangle = \langle \omega r \rangle$.

С микроскопич. точки зрения, сверхтекучесть в ^4He связана с явлением *Бозе — Эйнштейна конденсация*, хорошо изученным на примере модели слабобезидеального бозе-газа (Н. Н. Боголюбов, 1947). Когерентное сверхтекучее состояние возникает в результате перехода макроскопич. части атомов в состояние бозе-конденсата. В случае слабого взаимодействия частиц бозе-конденсация означает накопление атомов в одностичном состоянии с наим. энергией, соответствующей нулевой импульсу. Атомы, находящиеся в бозе-конденсате, описываются одной и той же волновой ф-цией, и поэтому их движение микроскопически когерентно. Параметр порядка ψ определяется в этом случае как ср. значение по статистич. ансамблю от квантомеханич. оператора $\hat{\psi}$ уничтожения атомов ^4He в формализме *вторичного квантования*: $\psi = \langle \hat{\psi} \rangle$. Модуль параметра порядка при таком определении совпадает с плотностью n_0 атомов, имеющих нулевой импульс: $|\psi|^2 = n_0$. Плотность бозе-конденсата n_0 при $T = 0$ в слабобезидеальном бозе-газе не совпадает с плотностью газа (совпадение имеет место лишь в идеальном бозе-газе). В реальном сверхтекучем ^4He не величина n_0 , измеренная посредством рассеяния нейтронов, составляет при низких темп-рах всего $\sim 0,1\rho$, что указывает на весьма сильное взаимодействие атомов ^4He между собой. С др. стороны, плотность сверхтекучей компоненты как в слабобезидеальном бозе-газе, так и в ^4He при $T = 0$ совпадает с плотностью жидкости, т. е. в осн. состоянии жидкости атомы с нулевым и ненулевым импульсами образуют единый когерентный конденсат, а тепловые возмущения и нормальная компонента отсутствуют. При достаточно большом взаимодействии между атомами жидкости величина n_0 , а вместе с ней и параметр порядка ψ сверхтекучего состояния могут обратиться в нуль.

Существование параметра порядка ψ , являясь достаточным условием S_c , не является при этом необходимым ед. условием. Так, для двумерных сверхтекучих систем (близка гелия на твёрдой поверхности) $\psi = \langle \hat{\psi} \rangle = 0$ при любой конечной темп-ре. Причиной этого являются растущие с ростом размеров системы тепловые флуктуации фазы [П. Хоэнберг (P. Hohenberg), 1967]. Тем не менее имеется темп-ра перехода T_c , ниже к-рой возникает сверхтекучая компонента с плотностью ρ_s . При низких темп-рах ($T \ll T_c$) в сверхтекучей плёнке хорошо выражен ближний порядок: фаза параметра порядка в точках r и r' сильно коррелируют между собой. Разность фаз

$$\langle \psi(r) - \psi(r') \rangle \sim \frac{T}{T_c} \ln \frac{|r - r'| + \xi}{\xi} \quad (3)$$

существенно меньше 2λ вплоть до расстояний $|r - r'| \leq \frac{1}{2} \xi_{\text{ex}}(T, T)$. В больших расстояниях правая часть ф-лы (3) расходится, свидетельствуя об отсутствии дальнего порядка, но сохраняется т. н. топологический дальний порядок к, связанный с тем, что набор фазы на $2\lambda N$ по замкнутому контуру сохраняется несмотря на флуктуации. В результате хорошо определены квантованные вихри, а в замкнутой кольцевой плёнке возможны разл. классы незатухающих течений с разными квантами циркуляции N (В. Березинский, 1971).

В отличие от трёхмерного случая, С. в плёнке возникает скачком, причём величина скачка $\Delta\varphi$ связана с темп-рой перехода универсальным соотношением:

$$\Delta\varphi_0 = (2m^2/\lambda^2) T_c \quad (4)$$

[Дж. Костерлиц, Д. Таулес (J. Kosterlitz, D. Thouless), 1973]. Исчезновение С. связано с образованием при $T = T_c$ квантованных вихрей топологического знака $\pm N = \pm 1$, к-рые разрушают топологический дальний порядок. Соотношение (4) для плёнки ^4He не проверено экспериментально [Д. Бишоп, Дж. Репин (D. Bishop, J. Perry), 1978].

В жидком ^3He , состоящем из атомов со спином $1/2$, переход в сверхтекучее состояние происходит так же, как и переход в сверхпроводящее состояние в металлах, посредством *Купера эффекта* — объединения квазицест в противоположные импульсами p и $-p$ вблизи ферми-поверхности в пары. Т. о., сверхтекучее состояние ферми-жидкости характеризуется появлением отличного от нуля среднего по статист. ансамблю от произведения двух операторов уничтожения:

$$F_{p, \alpha\beta} = \langle \bar{a}_{p\alpha}^- a_{p\beta}^- \rangle. \quad (5)$$

Здесь индексы α, β измеряют проекции спина частиц. Образование такого аномального среднего означает нарушение калибровочной инвариантности: при калибровочном преобразовании оператор $a_{p\alpha}^-$ переходит в $\bar{a}_{p\alpha}^- \exp i\chi$, что мненет энергию системы, но изменяет ф-цию F , характеризующую состояние системы, $F \rightarrow F \exp 2i\chi$. Как и в сверхтекучем ^4He нарушение калибровочной симметрии приводит к С., т. е. к существованию бездиссипативного переноса массы в сверхтекучем ^3He или элктрич. заряда в сверхпроводниках. Физ. свойства конкретных сверхтекучих жидкостей (сверхпроводников) определяются симметрией ф-ции $F_{p, \alpha\beta}$, т. е. совокупностью преобразований, сохраняющих её значение. Системы, характеризующиеся одинаковой симметрией ф-ции $F_{p, \alpha\beta}$, обладают одинаковыми сверхтекучими (сверхпроводящими) свойствами, в соответствии с чем все сверхпроводящие и сверхтекучие системы разбиваются на классы систем с одинаковой симметрией. Так, обычный сверхпроводник с s -спариванием квазицест обладает изотропной по импульсам и спинам ф-цией F и тем самым относится к тому же классу С., что и сверхтекучий ^4He с изотропным и бесспиновым параметром порядка ψ , и поэтому имеет с ним много сходного, несмотря на др. механизм образования когерентного состояния.

В отличие от обычных сверхпроводников, куперовские пары в ^3He обладают спином $S = 1$ и орбитальным моментом $L = 1$, т. е. ф-ция F у ^3He не является изотропной. В результате все три известные сверхтекучие фазы ^3He ($^3\text{He}-B$, $^3\text{He}-A$, $^3\text{He}-A_1$) относятся к разл. классам С., причём ни один из этих классов не совпадает с классом С. обычного сверхпроводника и ^4He . В то время как $^3\text{He}-B$ по своим сверхтекучим свойствам очень похож на сверхтекучий ^4He , отличающийся от него другими (магнитными и жидкокристаллическими) свойствами, фаза A резко выделяется своими сверхтекучими свойствами. Ф-ция F A -фазы:

$$F_{p, \alpha\beta} = (\rho_1 \Delta_1 + i \Delta_2) i (d, \hat{\sigma}_i)_{\alpha\beta}, \quad (6)$$

где $\hat{\sigma} = (\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$ — матрицы Паули; d — единичный вектор, задающий направление спонтанной магн. анизотропии в A -фазе; единичные векторы Δ_1 и Δ_2 ортогональны друг другу, причём их векторное произведение l определяет направление спонтанного орбитального момента куперовской пары и жидкокристаллической анизотропии A -фазы. Для сверхтекучих свойств здесь существенно, что одновременно с нарушением калибровочной симметрии [группы $U(1)$] нарушена симметрия относительно пространственных вращений (группы SO_3), т. н. состояние A -фазы характеризуется тройкой векторов Δ_1, Δ_2, l , к-рые преобразуются при вращении координатного пространства (см. *Гейзи жидкий*). При этом сохраняется комбинированная симметрия K $U(1) \times O(3)$, соответствующая неизменности F при калибровочных преобразованиях, выполняемых одновременно с поворотами на угол 2χ вокруг вектора l . Это приводит к след. сверхтекучим свойствам, связанным от жидкокристаллической анизотропии A -фазы.

1. Плотность сверхтекучей компоненты является основным тензором, т. е. сверхтекучий ток j_s , вообще говоря, не параллелен v_s :

$$j_s^i = \rho_s^i v_s^k - \rho_{0k}^i v_s^k. \quad (7)$$

Здесь δ^{ik} — Кронекера символ, по повторяющимся индексам $T_{\alpha\beta}$ осуществляется суммирование, $\rho_0 \rightarrow \rho_0/2$ при $T \rightarrow T_c$ и $\rho_0 \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$.

2. Если вектор l меняется в пространстве, то скорость сверхтекучего течения $v_s = (\hbar/2m)\Delta_1 \nabla \Delta_1$ является потенциальной: циркуляция $\oint v_s dr$ по замкнутому контуру зависит от пути интегрирования и может принимать любые, а не только квантованные значения, т. е. потенциальность течения — отнюдь не обязательный атрибут сверхтекучего движения.

3. В кольцевых каналах достаточно большого радиуса существуют только два класса течений, в то время как при включении достаточно сильного магн. поля, а также в узких каналах классы течений характеризуются произвольным целочисленным индексом N , как в ^4He , а в ряде случаев даже двумя целочисленными индексами N_1 и N_2 . Такое разнообразие свойств является следствием особенностей топологии структуры пространства вырожденных состояний в A -фазе.

4. Отличие этого пространства состояний от окружающей, имеющей место в сверхтекучем ^4He , приводит также к др. свойствам квантованных вихрей по сравнению с ^4He . Так, вихрь с одним квантом циркуляции (квант циркуляции в сверхтекучем ^3He равен $\hbar/2m$) имеет сингулярный кор, внутри к-рого сверхтекучее состояние отличается от A -фазы, а вихрь с двумя квантами циркуляции вообще не имеет сингулярного кора и поэтому часто бывает энергетически более выгодным, чем два одноквантовых вихря. При вращении сосуда в присутствии магн. поля возникают вихревые решётки, состоящие как из сингулярных, так и несингулярных вихрей. При уменьшении поля решётка несингулярных вихрей становится энергетически более выгодной, образуя непрерывную периодич. структуру вектора l с твердотельным (в ср.) распределением скорости сверхтекучего движения (v_s) = $\langle \omega \rangle$. Существенно, что С. не нарушена ни в одном из вихрей: внутри сингулярного кора одноквантового вихря вместо нормальной жидкости формируется ещё одна сверхтекучая фаза — т. н. полярная фаза. Даже в $^3\text{He}-B$, где все вихри, как и в ^4He , сингулярны, кор вихря тем не менее является сверхтекучим: помимо A -фазы в коре имеется сверхтекучая магн. жидкость, в результате вихрь обладает спонтанным магн. моментом.

5. Цель в центре квазицест в A -фазе обращается в нуль в двух точках $p = \pm p_f l$ на ферми-поверхности, поэтому критич. скорость Ландау для рождения возбуждений равна нулю. Это приводит к уменьшению ρ_s за счёт рождения квазицест при движении сверх-

текучей компоненты, в результате чего нормальная компонента существует даже при $T = 0$: её плотность пропорциональна $(\mu)^2$, а в пространственно неоднородном поле вектора \mathbf{l} пропорциональна $|\nabla \mathbf{l}|$.

6. Имеется третий механизм взаимодействия между сверхтекучей и нормальной компонентами (помимо квантовых вихрей и рождающихся квазичастиц) за счёт пространственно-временных изменений вектора \mathbf{l} . Поскольку динамика вектора \mathbf{l} тем самым определяет сверхтекучее движение, двухжидкостная гидродинамика Ландау включает урны для \mathbf{l} . Урны (2) и модифициров. системы урны гидродинамики для А-фазы принимает следующий вид (при $v_n = 0$):

$$\frac{\partial v_n}{\partial t} = -\nabla \mu + \frac{\hbar}{2m} \epsilon_{ijk} l_i \frac{\partial l_j}{\partial t} \nabla l_k, \quad (8)$$

где ϵ_{ijk} — антисимметричный тензор. Это урны отражает тот факт, что v_n может уменьшаться с помощью пространственно-временных осцилляций вектора \mathbf{l} , осуществляющих проскальзывание фазы. Бездиссипативный поток массы осуществляется только при стационарном \mathbf{l} и при $\nabla \mu = 0$. При наличии $\nabla \mu \neq 0$ формируется диссипативное токовое состояние сверхтекучей компоненты, в к-ром ускорение за счёт $\nabla \mu$ компенсируется периодическими осцилляциями вектора \mathbf{l} , вызывающими диссипацию в системе квазичастиц. Подобный периодич. процесс, представляющий собой аналог объёмного вестационарного эффекта Джозефсона, наблюдается экспериментально.

Магн. сверхтекучая фаза A_1 помимо сверхтекучих свойств, характерных для А-фазы, обладает ещё рядом свойств, вытекающих из дополнит. комбинаров. инвариантности состояния A_1 -фазы, связывающей сверхтекучее поведение с магнитным. В частности, во втором звуке, распространяющемся в A_1 -фазе, колеблется не только зитрония, но и намагниченность.

С. — весьма распространённое в природе явление. Помимо сверхтекучего ^4He и сверхтекучих фаз ^3He (в ^3He - B кроме обыкновенного наблюдается также синовая сверхтекучесть), а также заряд. сверхтекучей электронной жидкости в сверхпроводниках следует упомянуть С. в системе нуклонов в нейтронных звёздах — пульсарах и сверхтекучие корреляции в атомных ядрах (Н. Н. Боголюбов, 1958). Среди заряженных сверхтекучих систем выделяются сверхпроводящие металлы с тяжёлыми фермионами, сверхпроводимость к-рых весьма вероятно относится к классам С., характеризующим комбинаров. нарушением калибровочной и кристаллич. симметрии и симметрии по отношению к обращению времени (Г. Е. Волков, Л. П. Горьков, 1984). Родственные сверхпроводимости (или С.) явления наблюдаются также в двумерных электронных системах в присутствии сильного магн. поля, где образуются электронные квантовые жидкости с бездиссипативным потоком массы и электрич. заряда, имеющим место при квантующихся значениях постоянной Холла (см. Квантовый Холл эффект). Интенсивно исследуются на предмет обнаружения С.: спин-поляризованный атомарный водород — единств. реальный объект, соответствующий модели слабевидеального газа-газа; слабый раствор ^3He в сверхтекучем ^4He ; наконец, кристаллич. фазы ^3He и ^4He , в к-рых возможна С. жидкости вакансий (А. Ф. Андреев, И. М. Лифшиц, 1969).

Лит.: Халатников И. М., Теория сверхтекучести, М., 1971; Фейнман Р., Статистическая механика, пер. с англ., 2 изд., М., 1978; Натаншир А. С., Понороски и В. П., Фундаментальная теория фазовых переходов, 2 изд., М., 1982; Сверхтекучесть гелия-3. Сб. ст., пер. с англ., М., 1977; Паттерман С., Гидродинамика сверхтекучей жидкости, пер. с англ., М., 1978; Мияека В. П., Сверхтекучий ^3He . Выпущен в свет, «УФН», 1983, т. 139, в. 2, с. 303; Воловик Г. Е., Сверхтекучие свойства А-фазы ^3He , «УФН», 1984, т. 143, с. 73. Г. Е. Волков, В. П. Миусев. СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ АТОМНЫХ ЯДЕР — коррелированное движение нейтронов и протонов в средних и тяжёлых ядрах, аналогичное движению электронов

в сверхпроводниках. Идея С. а. я. была выдвинута в 1958 О. Бором, Б. Моттelsonом и Д. Пайсоном [1] под влиянием теории сверхпроводимости электронов в металлах. В металлах притяжение между находящимися вблизи поверхности Ферми электронами, обусловленное обменом фононами, может приводить к образованию связанных состояний квазичастиц — к у н е р о в с к и х п а р. При низкой темп-ре эти пары образуют Bose-конденсат (см. Bose — Эйнштейна конденсация), сверхтекучесть к-рого и приводит к сверхпроводимости металла. Энергия связи пары Δ играет роль параметра порядка для фазового перехода из нормальной фазы металла в сверхпроводящую. Она определяет и энергетич. щель в одночастичном спектре сверхпроводника. Так, в нормальном проводнике спектр имеет вид $\mathcal{E}(p) = (p - p_F)p/m_e$, где p — импульс квазичастицы, p_F — ферми-импульс, m_e — эффективная масса электрона; в сверхпроводнике:

$$\mathcal{E}(p) = \sqrt{\mathcal{E}^2(p) + \Delta^2}.$$

Притяжение между тождеств. нуклонами в синглетном (спин $S = 0$) s-волновом состоянии приводит к аналогичному эффекту в атомных ядрах (см. Сверхтекучая модель ядра). Однако при этом оказывается, что размер формально введённой куперовской пары порядка или даже больше размера ядра ($\sim \hbar/\sqrt{m_N \Delta} \sim 40$ ф. т. к. в средних и тяжёлых ядрах $\Delta \sim 1$ МэВ). Поэтому реально связанное состояние пары нуклонов в ядре не образуется и можно говорить только о парных корреляциях протонов и нейтронов в средних и тяжёлых ядрах. Тем не менее многие качеств. эффекты сверхтекучести в атомных ядрах проявляются. Как и в случае электронов в сверхпроводнике, изменяется одночастичный спектр нуклонов. Если в несверхтекучем ядре он определяется одночастичными энергиями нуклонов \mathcal{E}_i в среднем поле ядра (см. Обобщённая модель ядра), то при учёте корреляции энергии частичек и дырочных возбуждений вблизи поверхности Ферми нейтронов и протонов даются выражением:

$$\mathcal{E}_\lambda = \pm \sqrt{(\mathcal{E}_\lambda - \mathcal{E}_F)^2 + \Delta^2},$$

где \mathcal{E}_F — химический потенциал протонов или нейтронов в ядре (рис. 1).

В тех случаях, когда просвет между уровнями энергии ядра заметно превышает Δ , эффекты сверхтекучести несущественны. Именно такая ситуация осуществляется в *малых ядрах*, к-рые являются несверхтекучими. Однако при добавлении всего неск. нуклонов сверхтекучесть возникает. В полуматрич. ядрах сверхтекучесть существует только для нуклонов с немагн. спином.

Др. эффект С. а. я. — кардинальное изменение чисел заполнения частиц вблизи поверхности Ферми. В идеальном ферми-газе распределение частиц по импульсам $n(p)$ имеет вид единичной «ступеньки»: $n = \theta(p - p_F)$ (см. Ферми-распределение). В нормальной фермижидкости взаимодействие между частицами лишь уменьшает величину ступеньки $n(p)$, но сам факт существования скачка остаётся

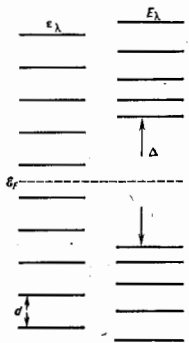
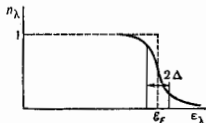


Рис. 1. Влияние спаривания на одночастичный спектр нуклонов в модели окисидатных уровней; $\Delta = 2d$, d — расстояние между соседними уровнями ϵ_λ .

ся в силе, т. е. распределение квазичастиц по-прежнему имеет вид единичной ступеньки. Сверхтекучесть размывает эту ступеньку на интервал $\sim \Delta$. Аналогично, в несверхтекучем ядре квазичастицы распределены по одночастичным состояниям λ по закону $n_\lambda = \theta(\mu - \epsilon_\lambda)$. Учёт парных коррелиций делает переход от $n_\lambda = 1$ к $n_\lambda = 0$ плавным, с характерным масштабом $|\epsilon_\lambda - \mu| \sim \Delta$ (рис. 2). Этот эффект —

Рис. 2. Числа заполнения n_λ для невакцидирующихся частиц (пунктирная ступенька) и с учётом спаривания (сплошная кривая).



дробное заполнение уровней вблизи поверхности Ферми — влияет на вероятности ядерных β - и γ -переходов. Так, для одночастичного перехода $\lambda_1 \rightarrow \lambda_2$ появляется фактор $n_{\lambda_1}(1 - n_{\lambda_2}) < 1$, k -ый уменьшает вероятность перехода иногда на порядок. Существенно влияет $S. a. j.$ и на *альфа-распад*.

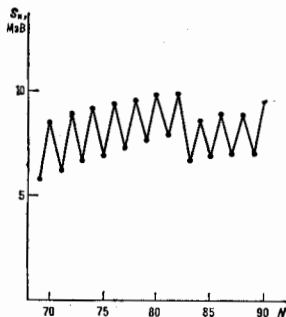


Рис. 3. Чётно-нечётный эффект в энергиях отделения нейтрона от ядра при фиксированной асимметрии нейтронного избытка в ядре $N - Z = 21$.

Парные корреляции объясняют и чётко-нечётное «дрожание» энергий связи ядер $B(N, Z)$. Здесь N — число нейтронов, Z — число протонов в ядре или энергии отделения нейтрона и от ядра

$$S_N(N, Z) = B(N, Z) - B(N-1, Z)$$

(рис. 3). Энергетич. щель Δ приближённо может быть извлечена из разностей энергий связи или $S_N(N, Z)$. Так, для нейтронов

$$\Delta_n(N, Z) = -\frac{1}{4} [S_N(N-1, Z) + S_N(N+1, Z) - 2S_N(N, Z)] \quad (1)$$

Аналогично вычисляется $\Delta_p(N, Z)$. Значения Δ , извлекаемые из соотношения (1), могут быть приближённо аппроксимированы соотношениями:

$$\Delta_{n,p} \approx 12/\sqrt{A}, \text{ МэВ}, \quad (2)$$

где $A = N + Z$. Однако есть заметные отклонения от (2), особенно вблизи магич. ядер, и (2) не имеет явного флз. смысла.

Наиб. ярко сверхтекучие свойства проявляются в *деформированных ядрах*. Квантовая ферми-система, не обладающая сверхтекучестью, должна иметь такой же момент инерции, как твёрдое тело того же объёма и формы. Существенно меньшие (в 2—2,5 раза) эксперим.

значения моментов инерции деформиров. ядер не объяснила оболочечная модель. Учёт сверхтекучести естественно объясняет этот эффект.

Сверхтекучесть *высококипящих состояний* ядер позволяет обнаружить ряд особенностей их спектров (т. к. обратный загиб, двойной обратный загиб). Эти особенности обусловлены фазовыми переходами в ядрах, вызванными ростом угл. момента. Фазовый переход может быть связан либо с изменением формы ядра (напр., возникновением аксиальной деформации), либо с изменением характера спаривания. Так, обратный загиб связывают с разрушением парной корреляции нуклонов под влиянием вращения. Возможно, эти особенности спектров связаны с возникновением в возбуждённых высококипящих состояниях ядер трагического спаривания [3], к-рое может быть результатом притягательного взаимодействия нуклонов в r -состоянии со спином $S = 1$ (гл. обр. спин-орбитального). Гипотеза триплетного спаривания приводит к ряду предсказаний, напр. для вероятностей магн. γ -переходов.

Природа $S. a. j.$ не вполне ясна. Подходы в теории ядра, основанные на первых принципах (напр., теория Бете — Брукнера), приводят для синглетного состояния либо к отталкивательному взаимодействию нуклонов, либо к притяжению, слишком слабому для возникновения сверхтекучести. В отличие от бесконечных систем, где для возникновения спаривания достаточно сколь угодно слабого взаимодействия, в ядрах энергия притягательного взаимодействия должна быть сравнима с расстоянием между уровнями у поверхности Ферми. Результаты этих теорий ставят под сомнение объёмный характер спаривания в ядрах. В то же время на поверхности ядра в этом состоянии должно быть сильное притяжение, связанное с резонансным характером взаимодействия нуклонов малой энергии в пустоте. Т. к. реально существующие ядра — сравнительно небольшие системы, этого поверхностного притяжения может оказаться достаточно для того, чтобы эфф. взаимодействие оказалось притягательным и нужной величины [4].

Большинство эффектов сверхтекучести мало зависят от её природы (объёмной или поверхностной). Наиб. чувствительны к этому реакции двухнуклонной передачи (см. *Прямые ядерные реакции*). Однако данные не столь прецизионны, а теория этих реакций не столь точна, чтобы сделать чёткое различие между двумя крайними случаями. Возможна и промежуточная ситуация, когда взаимодействие притягательно и внутри ядра и на поверхности, но поверхностное притяжение гораздо сильнее и играет существенную роль в спаривании.

Лит.: 1) Vogt A., Mottelson B. P., Pines D., Possible analogy between the excitation spectra of nuclei and that of the superconducting metals state, *Phys. Rev.*, 1958, v. 110, № 4, p. 936; 2) Соловьёв В. Г., Теория сложных ядер, *М.*, 1971; 3) Фальков В. И., Шаниро И. С., Триплетное спаривание в ядрах, *Изв. АН ССР*, 1965, т. 31, в. 4, с. 1194; 4) Мигдал А. Л., Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер, 2 изд., *М.*, 1983. Э. Э. Сегельштейн

СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА (сверхтонкое расщепление) уровней энергии и — расщепление уровней энергии атома, молекулы или кристалла на неск. подуровней, обусловленное взаимодействием магн. момента ядра с магн. полем, создаваемым гл. обр. электронами, а также взаимодействием квадрупольного момента ядра с неоднородным внутриатомным электр. полем. Вследствие сверхтонкого расщепления уровней в оптич. спектрах атомов и молекул вместо одной спектральной линии возникает группа очень близких линий — $S. c.$ спектральных линий.

Если ядро атома или одно из атомных ядер молекулы имеет спин I , то каждый подуровень $S. c.$ характеризуется полным моментом $F = J + I$, где J — векторная сумма полного электронного момента и момента орбитального движения ядер. Квантовые числа F полного момента принимают значения $F = |J - I|, |J - I| + 1, \dots, J + I$ (J и I — квантовые числа пол-

ного механич. электронного и ядерного спинного моментов). При $J \geq 1$ число подуровней равно $2J + 1$, а при $J < 1$ оно равно $2J + 1$. Энергия ϵ подуровня записывается в виде:

$$\epsilon_F = \epsilon_J + \epsilon_{M1} + \epsilon_{E2},$$

где ϵ_J — энергия уровня в пренебрежении С. с., ϵ_{M1} — энергия магн. диполь-дипольного взаимодействия, ϵ_{E2} — энергия электр. квадрупольного взаимодействия.

В атомах и ионах осн. роль играет магн. взаимодействие, энергия к-рого

$$\epsilon_{M1} = \frac{1}{2} h A C, \quad C = F(F+1) - I(I+1) - J(J+1);$$

константа A (Гц) определяется усреднением по состоянию с полным моментом F оператора магн. взаимодействия электронов с ядерным моментом $\hat{V}_{M1} = h A I J$. Величина взаимодействия пропорц. ядерному магнетону $\mu_N = (m/m_p)\mu_B$, где μ_B — магнетон Бора, m — масса электрона и m_p — масса протона. Расстояние между подуровнями С. с. в атоме примерно в 1000 раз меньше, чем расстояние между компонентами тонкой структуры. Характерные величины сверхтонкого расщепления (ϵ_{M1}/h) для основного состояния атомов порядка одного или неск. Гц. Сверхтонкое расщепление возбужденных уровней энергии убывает пропорц. энергии связи возбужденного электрона в степени $3/2$ и быстро уменьшается с увеличением орбитального момента электрона. В случае водородоподобных атомов (H, He⁺ и т. д.)

$$A = \frac{(Ry/2\pi\hbar) \alpha^2 Z^2}{n^2(1+1/2)J(J+1)} \cdot \frac{m}{m_p} g_I,$$

где $Ry = me^4/2\hbar^2$ — Ридберга постоянная, α — тонкой структуры постоянная, Z — заряд ядра (в единицах заряда электрона), n и l — главное и орбитальное квантовые числа, g_I — ядерный Ланде множитель.

Электрич. квадрупольное взаимодействие существует при $J \geq 1$ для несферич. ядер с $I \geq 1$. Оно даёт поправки к энергии подуровней атома

$$\epsilon_{E2} = \frac{3h}{8} B \frac{C(C+1) - 4/3I(I+1)J(J+1)}{I(2I-1)J(2J-1)}.$$

Константа B определяется усреднением по состоянию с полным моментом F оператора квадрупольного взаимодействия

$$V_{E2} = 3/4\pi B \{ \hat{i}_i \hat{k}_k + \hat{i}_k \hat{i}_l - 2/3I(I+1)\delta_{ik} \} \hat{j}_i \hat{j}_k,$$

где $i, k = 1, 2, 3$, δ_{ik} — Кронекера символ. Обычно постоянная квадрупольного взаимодействия B на один-полтора порядка меньше константы A . Квадрупольное взаимодействие приводит к нарушению правила интервалов Ланде.

Для дипольных переходов между подуровнями С. с. разных уровней выполняется отбора правила: $\Delta F = 0, \pm 1$; $F + F' \geq 1$. Между подуровнями С. с. одного уровня разрешены магн. дипольные переходы с указанными выше правилами отбора, а также электр. квадрупольные переходы с правилами отбора $\Delta F = 0, \pm 1, \pm 2$; $F + F' \geq 2$.

Почти у всех молекул в основном электронном состоянии суммарный механич. момент электронов равен нулю и магн. С. с. колебательно-вращат. уровней энергии гл. обр. связана с вращением молекулы. В случае двухатомных, линейных многоатомных молекул и молекул типа симметричного волчка (см. Молекула), содержащих одно ядро со спином I на осн. молекулы,

$$\epsilon_{M1} = h \frac{\alpha K^2}{J(J+1)+b} C,$$

где J и K — квантовые числа полного вращат. момента и его проекция на ось волчка соответственно. Магн. расщепления составляют $1-100$ кГц. Если спином обладают неск. ядер молекулы, то вследствие магн.

взаимодействий ядерных моментов возникает дополнит. расщепления порядка неск. кГц. Магнитная С. с. уровней энергии молекул, обладающих электронным моментом, того же порядка, что и для атомов.

Если молекула в состоянии $^1\Sigma$ содержит на своей осн. ядро с $I \geq 1$, гл. роль играет квадрупольное расщепление:

$$\epsilon_{E2} = \frac{3}{8} h \beta \left(\frac{3K^2}{J(J+1)} - 1 \right) \frac{C(C+1) - 4/3I(I+1)J(J+1)}{I(2I-1)(2J-1)(2J+3)},$$

где β (Гц) — константа, характерная для уровня с данными K и J . Величины квадрупольных расщеплений составляют десятки и сотни МГц.

В растворах, стёклах и кристаллах С. с. могут, напр., иметь уровни энергии примесных ионов, свободных радикалов, электронов, локализованных на дефектах решётки.

С. с. изучается методами магн. резонанса, др. методами радиоспектроскопии. Для возбужденных состояний используются методы двойного резонанса (оптический — радиочастотный, инфракрасный — радиочастотный резонансы), а также методы нелинейной лазерной спектроскопии.

Раад. изотопы хим. элементов обладают раад. значениями ядерного спина, а их линии испытывают изотопич. сдвиг. Поэтому часто происходит наложение спектров разных изотопов и С. с. спектральных линий дополнительно усложняется.

Лит.: Таунс Ч., Шавлов А., Радиоспектроскопия, пер. с англ., М., 1959; Соболев И. И., Введение в теорию атомных спектров, 12 изд., М., 1977; Аглицкий Л. И., Theory of the hyperfine structure of free atoms, N. Y. — La. o., 1971; Радиг А. А., Смирнов В. М., Параметры атомов и атомных ионов. Справочник, 2 изд., М., 1956.

СВЕРХТОНКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — взаимодействие магн. и квадрупольного моментов ядер с магн. и электростатич. полями окружающих электронов. С. в. приводит к сверхтонкой структуре энергетич. уровней в атомах, молекулах и твёрдых телах с характерными энергетич. масштабами, на 3 порядка меньшими масштаба тонкой структуры, связанной со спин-орбитальным взаимодействием. Число подуровней сверхтонкой структуры равно $2I + 1$, если спин ядра I меньше момента электронной оболочки J , и $2J + 1$ в противном случае.

Гамильтониан С. в. \mathcal{H} имеет вид:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_2 = -\mu H + \frac{1}{6} \sum_{\alpha, \beta} Q_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial r_{\alpha} \partial r_{\beta}},$$

где \mathcal{H}_0 и \mathcal{H}_2 — гамильтонианы магн. и квадрупольного взаимодействий; H и ψ — напряжённость магн. поля и электростатич. потенциал, создаваемые электронами в месте нахождения ядра; μ и $Q_{\alpha, \beta}$ — e ($3g_r g_B - r^2 \delta_{\alpha\beta}$) — магн. и квадрупольные моменты ядра, e — заряд электрона. Здесь угл. скобки (...) означают усреднение по волновым ф-циям ядра, r_x и r_y — компоненты вектора r ; индексы $\alpha, \beta = x, y, z$, ось z направлена вдоль спина ядра. Величины μ и $Q_{\alpha, \beta}$ можно выразить через ядерный спин:

$$\mu = \mu_N \left(\frac{m_p}{m_p} \right) g_I I; \quad Q_{\alpha, \beta} = \frac{3}{2} \frac{Q}{I(2I-1)} \times \left(I_{\alpha} I_{\beta} + I_{\beta} I_{\alpha} - \frac{2}{3} I^2 \delta_{\alpha\beta} \right),$$

где $\mu_B = eh/2mc$ — магнетон Бора, m_p , m_p — массы электрона и протона, g_I — гиромагнитное отношение, Q — ср. по волновым ф-циям ядра значение компонент Q_{zz} в состоянии с макс. проекцией спина на ось z , $\delta_{\alpha\beta}$ — Кронекера символ. Магн. поле H , создаваемые электронами в месте нахождения ядра, является суммой поля, обусловленного орбитальным движением электронов $H_0 = -\mu_N(2I^2/r^3)$ и поля H_2 , связанного с распределением спиновой плотности. Поле H_0 может быть представлено в виде суммы поля, соответствующего магнитодипольному взаимодействию $H_{d1} = \mu_N(2I^2/r^3) \times$

$\times [sr^2 - 3(sr)r]$, и поля, соответствующего контактому $\mathbf{H}_{30} = -\mu_B(16\pi/3)\psi^2(0)/s$, где $\psi(0)$ — волновая функция электрона в месте нахождения ядра, s — спин электрона. Для электронов с нулевым орбитальным моментом (s -электроны) \mathbf{H}_{31} и \mathbf{H}_3 обращаются в нуль и остаются только контактное взаимодействие. Напротив, для электронов с орбитальным моментом $l > 0$ обращается в нуль контактное взаимодействие и остаются \mathbf{H}_{31} и \mathbf{H}_3 .

Расщепление уровней в атомах и молекулах, к-рому приводит С. в., по порядку величины равно $\alpha^2(m_e/m_p)^2 Z^2 Ry$ для магн. части взаимодействия $\mathcal{H}_m \approx (Q/a)^2 Z^2 Ry$ для квадрупольных взаимодействий, \mathcal{H}_q , где $a = e^2/\hbar c$ — тонкой структуры постоянная, Z — заряд ядра, $Ry = e^2/2a_0$ — единица Ридберга для энергии, a_0 — Бора радиус. Характер расщепления ΔE_F определяется величиной $\langle J \rangle$, усреднённой по собств. состоянию системы $|FMJ\rangle$ с полным моментом $F = I + J$; M — проекция полного момента:

$$\Delta E_F = \frac{1}{2} AC + BC(C+1),$$

где $C = 2 \langle FMJ | J | FMJ \rangle = F(F+1) - J(J+1) - l(l+1)$. Для водородоподобных ионов в состоянии с квантовыми числами n, l, m имеем:

$$A = \alpha^2 g_l^2 (m_e/m_p)^2 \frac{Z^2 Ry}{n^3} \begin{cases} 8/3, & \text{если } l=0, \\ 1, & \text{если } l>0; \end{cases}$$

$$B = \left(\frac{Q/a}{n} \right)^2 \frac{Z^2 Ry}{n^3} \cdot \frac{3}{8l(2l-1)j(j+1)(l+1)(l+1/2)}.$$

Для водородоподобных атомов, молекул и твёрдых тел расчёт магн. поля и градиента электрич. поля электронных оболочек в месте нахождения ядра весьма сложен. Он, как правило, связан с выходом за рамки обычного Хартри — Фока метода и требует громоздких расчётов. В частности, даже для щелочных элементов учёт спиновой поляризации остова может изменить значение постоянной A в 1,5 раза. В ряде случаев, напр. для атомов и ионов с валентными d -электронами, из-за спиновой поляризации меняется знак магн. поля. Для многозарядных ионов и тяжёлых ядер существенную роль начинают играть релятивистские эффекты и эффекты, связанные с конечным размером ядра.

Экспериментально С. в. исследуется методами лазерной спектроскопии, радиоспектроскопии, электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, ядерного квадрупольного резонанса, используются также методы гамма-спектроскопии, основанные на Мессбауэровском эффекте. Изучение сверхтонкого расщепления позволяет определить спины, магн. и квадрупольные моменты ядер, в т. ч. и в случаях, когда время жизни этих ядер мало. В свою очередь, благодаря С. в. ядра играют роль естеств. зонда, позволяющего исследовать электронную структуру твёрдых тел.

С. в. весьма существенно в спектроскопии мезоатомов, т. к. абс. величина сверхтонкого расщепления увеличивается в $(m_e/m_c)^3$ раз, где m_c — масса мезона, а относительная — в $(m_e/m_c)^2$ раз.

Переход между подуровнями сверхтонкой структуры основного состояния водорода даёт радиочастоту водорода 21 см, к-рая играет чрезвычайно важную роль в совр. радиоастрономии.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; Соболев Я. И., Введение в теорию атомных спектров, 12 изд., М., 1977; Сверхтонкие взаимодействия в твёрдых телах, пер. с англ., М., 1970; Лифшиц Е. М., Моргенштерн Я., Атомная физика, 2 ед., В.—(а. о.), 1986. И. Л. Бейман.

СВЕТ — 1) в узком смысле — то же, что и видимое излучение, т. е. эл.-магн. волны в интервале частот, воспринимаемых глазом ($7,5 \cdot 10^{14}$ — $4,0 \cdot 10^{14}$ Гц), что соответствует длинам волн в вакууме от ~ 400 до ~ 760 нм. С. очень высокой интенсивности глаз воспринимает в песчало более широким диапазоне. Свето-

вые волны разл. частот воспринимаются человеком как разл. цвета (подробнее см. в ст. Колориметрия).

2) С. в широком смысле — то же, что оптическое излучение. А. П. Гагарин.

СВЕТИМОСТИ КЛАССЫ — параметры спектральной классификации звёзд, характеризующие зависимость спектра звезды от её абс. видимой звездной величины M_V . С. к. определяются в т. н. йерсковой системе спектральной классификации звёзд (см. Спектральные классы).

Разделение звёзд на С. к. связано с зависимостью степени ионизации атомов в атмосферах звёзд от электронного давления и с зависимостью интенсивности спектральных линий от величины взаимодействия атомов с окружающими частицами. Эти зависимости различаются для звёзд с разными ускорениями силы тяжести в атмосфере g . Следствие масса — светимости зависимости величины g , в свою очередь, связана со светимостью звезды, мерой к-рой является абс. звездная величина. В йерсковой классификации определяются след. С. к. (табл.); не во всех спектральных классах представлены все С. к.).

Класс светимости	Название	Подразделения в порядке убывания светимости
0 (или Ia—0, Ia')	Сверхсверхгиганты или гипогиганты	Ia, Iab, Ib
I	Сверхгиганты	
II	Яркие гиганты	II—III, IIIa, IIIab, IIIb, III—IV
III	Гиганты	
IV	Субгиганты	
V	Карлики	

Иногда вводятся С. к. VI для субкарликов и С. к. VII для белых карликов. Наблюдаемая численность звёзд отдельных С. к. находит объяснение в рамках теории эволюции звёзд.

Лит. см. при ст. Спектральные классы. Л. Р. Юнгвальд.

СВЕТИМОСТЬ в астрономии — полная энергия, излучаемая источником в единицу времени. Часто С. выражают в единицах светимости Солнца $L_\odot \approx 3,86 \cdot 10^{33}$ эрг/с. Иногда говорят не о полной С., а о С. в нек-ром спектральном диапазоне. Напр., в зависимости от метода определения различают визуальную, фотографическую и др. светимости. С. источника излучения может быть найдена по его блеску и расстоянию до него. По известному расстоянию r определяют абс. звездную величину M , к-рая связана с видимой звездной величиной m соотношением

$$M = m + 5 - 5 \lg r - A(r),$$

здесь r выражено в парсеках, а величина $A(r)$ учитывает межзвёздное поглощение. С. связана с M соотношением

$$\lg(L/L_\odot) = 0,4(4,77 - M).$$

По видимой звездной величине объекта и его параллаксу l С. определяется по формуле

$$\lg(L/L_\odot) = -2 \lg p - 0,4m - 0,1 + 0,4A.$$

Для перехода от визуальной, fotogr. С. или С. определённой фотоэлектрич. методами, к полной С. необходимо ввести т. н. болометрическую поправку, учитывающую излучение, не зафиксированное данным приёмником. С. звёзд главной последовательности (см. Герцишпрунга — Рассела диаграмма) удовлетворяет соотношению масса — светимость: большим массам звёзд соответствуют большие светимости (см. Масса — светимость зависимости). С. стационарных звёзд и др. объектов, излучающих за счёт внутр. источников энергии, не превосходит т. н. критической светимости. А. М. Черепанин.

СВЕТИМОСТЬ точки поверхности — одна из *световых величин*, отношение *светового потока*, исходящего от элемента поверхности, к площади этого элемента. Единица С. (СИ) — люмен с квадратного метра (лм/м²). Аналогичная величина в системе энергии, величина наз. энергетической С. (излучательностью) и измеряется в Вт/м². Д. Н. Лазарев.

СВЕТИМОСТЬ ускорителя (L) — характеристика эффективности системы «ускоритель — мишень». Определяется как величина, равная числу событий, происходящих в единицу времени при единичном сечении взаимодействия частиц пучка и мишени (в т. ч. подвижной — *встречные пучки*): $L = n_0 N$, где n_0 — плотность частиц мишени, l — её толщина (диоль пучка), N — поток частиц на ускорителе. Для встречных пучков $L = (l/l_0)(N_1 N_2/S)$, где $l_0 > l$ (l — протяжённость сгустка частиц, l_0 — протяжённость участка пересечения пучков, N_1, N_2 — полное число частиц в каждом из пучков, S — площадь поперечного сечения большего из сгустков, f — частота обращения частиц в ускорителе). При ненулевом угле пересечения орбит сталкивающихся частиц и неполном перекрытии сечений сгустков в формуле появляется геом. коэф., меньший единицы. Размерность С. [L] = см²·с⁻¹. Для процесса исследуемого типа, характеризующего сечением σ , число событий в единицу времени равно $L\sigma$. И. Н. Мешков.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА — 1) С. о. атома — одно из *подвергожимых действий света*, заключающееся в том, что атом, испускающий фотон, приобретает импульс отдачи, направленный в сторону, противоположную вылету фотона. При спонтанном испускании разные атомы ансамбля получают импульсы отдачи в разл. произвольных направлениях; при вынужденном испускании — в одном определённом направлении. См. *Даление света*.

2) С. о. источника света — отношение излучаемого источником *светового потока* к потребляемой им мощности. Измеряется в люменах на Ватт (лм/Вт). Служит характеристикой экономичности источников; С. о. совр. ламп накаливания общего назначения 8–20 лм/Вт, люминесцентных — до 90 лм/Вт, металлогалогенных и натриевых — до 130 лм/Вт. См. также *Световая эффективность излучения*, *Источники оптического излучения*. Д. Н. Лазарев.

СВЕТОВАЯ ЭНЕРГИЯ — одна из основных *световых величин*, равная произведению *светового потока* на длительность освещения. Единица С. а. — люмен-секунда (лм·с). См. также *Спектральная световая эффективность*. В системе энергии, величина аналогичная величина — энергия излучения, единица измерения — Дж. Д. Н. Лазарев.

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ — отношение светового потока к соответствующему потоку излучения. Единица С. а. и. — лм·Вт⁻¹. См. также *Спектральная световая эффективность*. Д. Н. Лазарев.

СВЕТОВОД (волновод оптический) — закрытое устройство для направленной передачи света. В открытом пространстве передача света возможна только в пределах прямой видимости и ограничивается нач. расходимостью излучения, поглощением и рассеянием в атмосфере. Переход к С. позволяет значительно уменьшить потери световой энергии при её передаче на большие расстояния, а также передавать световую энергию по приводевым трассам.

Разработаны разнообразные типы С., среди них — *лиазовые* (зеркальные) С., представляющие собой систему заключённых в трубу и расходящихся на определённых расстояниях линз (зеркал), полые металлические трубы и др., однако они не нашли широкого применения.

Наиб. перспективный и широко применяемый в настоящее время (1990-е гг.) тип С. — гибкий диэлектрик.

волоконный С. с низкими оптич. потерями (см. *Волоконная оптика*), позволяющий передавать свет на большие расстояния. В простейшем варианте он представляет собой тонкую нить из оптически прозрачного материала, сердцевины к-рой радиуса a_1 имеет показатель преломления n_1 , а оболочка с радиусом a_2 имеет показатель преломления $n_2 < n_1$ (рис. 1). В приближе-

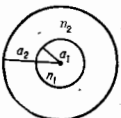


Рис. 1. Поперечное сечение волоконного световода.

нии геом. оптики лучи, входящие в сердцевину под достаточно малыми углами к оси С., испытывают *полное внутреннее отражение* на поверхности раздела сердцевины и оболочки и распространяются только по сердцевине.

В зависимости от назначения С. диаметр сердцевины $2a_1$ составляет от неск. мкм до неск. сотен мкм, а $2a_2$ — от неск. десятков до примерно тысячи мкм.

Величины $2a_1$ и $n_1 - n_2$ определяют число типов волн (мод), к-рые могут распространяться по С. при заданной длине волны света λ . Выбирая $2a_1$ и $n_1 - n_2$ достаточно малыми, можно добиться, чтобы С. работал в одномодовом режиме.

Волоконные С. находят широкое применение в системах *оптической связи*, в датчиках разл. физ. полей, в вычислит. технике, для канализации мощного лазерного излучения для медицинских и технол. целей и т.д.

Характеристики волоконных световодов. Важнейшими характеристиками С., предназначенными для подобных применений, являются оптич. потери, дисперсия групповой скорости, оптич. величина и механич. прочность. В 70-х гг. 20 в. созданы волоконные С. на основе кварцевого стекла с затуханием сигнала ~ 1 дБ/км в ближней ИФ-области спектра. Типичный спектр оптич. потерь α в таких С. представлен на рис. 2, а. Минимально возможные потери составляют $\approx 0,16$ дБ/км на волне 1,55 мкм. Материалом для таких С. служит кварцевое стекло; различия показателей преломления сердцевины и оболочки достигают легированием стекла (напр., фтором, германием, фосфором).

Др. важной характеристикой одномодовых волоконных С., широко применяемых в системах оптич. связи, является дисперсия скорости групповой скорости v_g . На рис. 2, б представлен спектр дисперсии С.

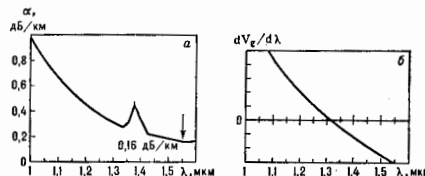


Рис. 2. Спектр оптич. потерь (а) и дисперсии групповой скорости $dv_g/d\lambda$ (произвольные единицы, б).

на основе кварцевого стекла. Видно, что кривая дисперсии проходит через 0 вблизи $\lambda \approx 1,3$ мкм. Это означает, что именно в этой спектральной области инфракрасного пропускания одномодовых волоконных С. на основе кварцевого стекла максимален и составляет $\approx 10^{11}$ Гц·км.

Изменением профиля показателя преломления волоконного С. можно сместить нуль дисперсии в область vicinity 1,55 мкм, где расположено абс. минимум оптической потери. Такие волоконные С. (со сдвинутой дисперсией) разработаны и находят большое применение в широкополосных системах дальней оптич. связи. Разработаны волоконные С. более сложной конструкции, напр. многослойные С. в т. ч. с сильными двухдисперсионными. Однодупольные С. последнего типа перспективны для применений, где необходимо сохранить поляризацию распространяющегося света.

Хотя стеклянные волоконные С. первоначально разрабатывались в качестве линейной передающей среды для систем оптич. связи, оказалось, что они являются перспективным нелинейным материалом. Оптическая нелинейность в стеклянных волоконных С. возникает в результате зависимости показателя преломления n от интенсивности лазерного излучения I : $n = n_0 + n' I$, где n_0 — линейная часть показателя преломления при произвольном низком значении интенсивности, не зависящая от интенсивности; n' — нелинейная добавка, n' — коэф., величина к-рого для кварцевого стекла равна $3,2 \cdot 10^{-16}$ см²/Вт. Малая величина n' для кварцевого стекла показывает, что оно не является хорошим нелинейным материалом. Однако, когда стекло используется в виде волоконного С., нелинейность может иметь большой эффект, что связано с малым сечением сердечника однодупольного волоконного С. $\sim 10^{-6}$ см². Это означает, что при введении в С. лазерного излучения мощностью 1 Вт интенсивность $I \sim 1$ МВт/см². Такая высокая интенсивность сохраняется на больших длинах С. вследствие его низких оптич. потерь, обеспечивая длину взаимодействия высокоинтенсивного излучения с веществом вплоть до неск. км. В результате в стеклянных волоконных С. эффективно протекают разнообразные нелинейные процессы при пороговых мощностях 1—10 мВт.

Наиб. интересным нелинейным эффектом, имеющим большое практич. значение, является солитонный режим распространения оптич. импульсов в волоконных С. в спектральной области отрицательной дисперсии групповой скорости ($\lambda > 1,3$ мкм, рис. 2, б).

В идеальном С. без потерь оптический солитон распространяется без изменения своей формы. Поэтому солитоны перспективны как носители информации в широкополосных и протяженных волоконно-оптич. системах связи. Разработаны лаб. солитонные системы связи, к-рые, как полагают, могут использоваться в коммерч. сетях связи в нач. 21 в.

При практич. использовании волоконных С. важной их характеристикой является механическая и прочност.

Теоретич. прочность на разрыв нитей из кварцевого стекла составляет 20—25 ГПа, макс. прочность С. на основе кварцевого стекла, защищенных полимерной плёнкой, равна 5—6 ГПа. Прочность высококач. волоконных С. зависит от поверхностных дефектов стекла (трещин, раковин и т. д.), к-рые в присутствии влаги под действием приложенных к С. напряжений увеличиваются, достигая уровня, при к-ром происходит разрушение С. Один из эффективных способов повышения прочности С. — нанесе-

ние на С. герметичных покрытий в процессе их изготовления. Нанесение металлиз. герметичных покрытий позволяет получать лаб. образцы С. с прочностью до 12—15 ГПа. На рис. 3 приведены ф-ции распределения прочности волоконных С. с полимерными (а) и металлиз. (б) покрытиями.

Изготовление и применение световодов. Волоконные С. на основе кварцевого стекла с низкими оптич. потерями изготавливают методом хим. осаждения из газовой фазы. В качестве исходных соединений используются кислород и хлориды кремния, германия, фосфора и др. Получаемая этим методом заготовка диам. 20—30 мкм и длиной 400—1000 м перетягивается в волоконный С. диам. ≈ 100 мкм с одновременным нанесением на него защитно-упрочняющей оболочки.

Кроме кварцевого стекла для волоконных С. используют также др. прозрачные в видимой и ИК-областях спектра материалы — многокомпонентные кислородные стекла, бескислородные стекла, полимеры и кристаллы. Однако волоконные С. на основе кварцевого стекла обладают наилучшими оптич. потерями и наивысшей механич. прочностью, поэтому они нашли самое широкое применение.

В 1990 в мире произведено св. 5 млн. км волоконных С. для волоконно-оптич. систем связи. В 1988 продолжена первая цифровая подводная волоконно-оптич. система связи между Америкой и Европой, а в 1989 — транстихокеанская волоконно-оптич. система Америка — Гавайские острова — Япония. В кон. 20 в. б. ч. телефонных разговоров на Земле производится по телеволоконным С.

В 80—90-х гг. разработаны волоконные С., легированные эрбием, перспективные в качестве активной среды в волоконных усилителях, накапливаемых излучением полупроводниковых лазеров. Эрбиевые волоконные усилители работают в спектральной области vicinity 1,55 мкм, совпадающей с областью мин. оптич. потерь совр. С., и являются альтернативой электронным ретрансляторам в широкополосных волоконно-оптич. системах дальней связи.

Для *интегральной оптики* разработаны диалектрич. волноводы — С., представляющие собой тонкую (порядка λ) плёнку, нанесённую на подложку. Условие волноводного режима распространения излучения заключается в том, что показатель преломления плёнки больше показателя преломления подложки и среды над волноводом. Диалектрич. С. этого типа изготавливают методом катодного распыления материала волновода на подложку, методом аэрозольного напыления на жидкой или газообразной фазе, методом *шпательной имплантации*.

Лит.: Мишвицер Д. Ж., Волоконные световоды для передачи информации, пер. с англ., М., 1983; Хансперджер В., Интегральная оптика, пер. с англ., М., 1986; Дьянов В. М., Волоконная оптика: проблемы и перспективы, «Вестник АН СССР», 1989, № 10, с. 41; Дьянов В. М., Дьянов В. М., Волоконно-оптическая связь: 20 лет спустя, там же, 1990, № 8, с. 143; Дьянов В. М., Прохоров А. М., Оптическая связь на основе нелинейных явлений в волоконных световодах, там же, 1990, № 10, с. 42. Е. М. Давлене.

СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ — см. Давление света.

СВЕТОВОЕ ПОЛЕ — поле светового вектора, пространственное распределение световых потоков. Теория С. п. — раздел теоретич. фотометрии. Осн. характеристики С. п. — световой вектор, определяющий величину и направление переноса лучистой энергии, и скалярная величина — ср. сферич. освещённость, определяющая объёмную плотность световой энергии в исследуемой точке поля. Распределение освещённости в исследуемой области общие методы расчёта пространственного распределения светового потока. В теории С. п. используют понятие о световых линиях, аналогично понятию силовых линий в классич. теории эл.-магн. поля. С. п. исследуют методами фотометрии; при этом не учитывают квантовую природу света, принимая, что распределение энергии в С. п. непрерывно по времени и пространству.

Лит. см. при стр. Фотометрия.

Л. Н. Нагорский.

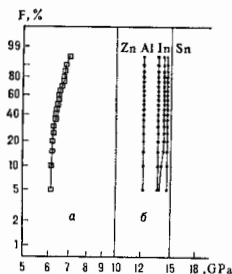


Рис. 3. Функции распределения прочности волоконных световодов на основе кварцевого стекла с полимерными (а) и герметичными металлиз. (б) покрытиями.

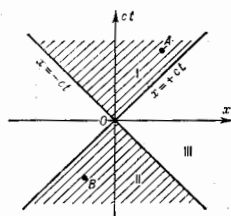
СВЕТОВОЙ ВЕКТОР — вектор плотности светового потока, определяет величину и направление переноса световой энергии. Абс. величина S в.—отношение световой энергии, переносимой через площадку ΔS , перпендикулярную направлению переноса, в единицу времени, к величине этой площадки. Понятие « S в.» используется гл. обр. в теоретич. фотометрии для количеств. описания световых полей и является фотометрич. аналогом *Пойнтинга вектора*. Так, дивергенция S в. определяет объёмную плотность поглощения или испускания света в данной точке светового поля. Проекция S в. на любое направление, проходящее через точку, равна разности освещённостей двух сторон малой площадки, помещённой в этой точке перпендикулярно данному направлению. Величина и направление S в. не зависят от системы координат.

Иногда S в. наз. вектор E напряжённости электрич. поля эл.-магн. волн. Это связано с тем, что именно действие электрол. поля на вещество приводит к поглощению, излучению, поляризации и др. оптич. явлениям. Л. Н. Натерский.

СВЕТОВОЙ ГОД — внесистемная единица длины, применяемая в астрономии. 1 С. г. равен расстоянию, проходимому светом за 1 год. 1 С. г. = 0,3088 парсек = 9,4605 · 10¹⁵ м.

СВЕТОВОЙ КОНУС — понятие, используемое при описании геом. свойств четырёхмерного пространства-времени в частной (специальной) и общей теории относительности. С. к., соответствующим данной точке пространства-времени, наз. трёхмерное подпространство в этом четырёхмерном пространстве, образованное совокупностью *мировых линий* свободно распространяющихся световых сигналов (или любых частиц с нулевой массой покоя), проходящих через эту точку (вершину конуса). Собств. длина мировых линий световых сигналов равна нулю. Поэтому С. к. наз. также нулевым конусом. Каждой точке четырёхмерного пространства-времени соответствует свой С. к.

В случае, если справедлива частная теория относительности, геометрия пространства-времени является псевдолокальной, наз. геометрией Минковского, в к-рой все точки пространства-времени равноправны (см. *Минковского пространство-время*). Поэтому достаточно рассмотреть С. к. с вершиной в начале координат $O: x = 0, y = 0, z = 0, t = 0$ (где x, y, z — пространственные координаты, t — время). Урн. поверхности С. к. с вершиной в O имеет вид: $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$; он инвариантен относительно *Лоренца преобразований*. Точки (события) с $x^2 + y^2 + z^2 \leq c^2t^2$ и $t > 0, t < 0$ образуют соответственно верхнюю (I) и нижнюю (II) полость С. к.; события с $x^2 + y^2 + z^2 > c^2t^2$ образуют область III вне С. к. Пересечение С. к. с плоскостью $y = 0, z = 0$ изображено на рисунке. Поверхность С. к. пересекает эту плоскость по прямым $x = \pm ct$. События A, лежащие в области I, образуют т. н. а б с о д л ю т н о е б у д у щ е е по отношению к событию O; события O могут оказать непосредств. воздействие на любое событие A, т. к. они могут быть связаны с O реальными сигналами или взаимодействиями. События в области II образуют а б с о л ю т н о е п р о ш е д ш е е для события O; любое событие B может являть на событие O, сигналы из B могут достичь O. События в области III не могут быть связаны с O никаким взаимодействием, т. к. никакие частицы и сигналы не распространяются быстрее света.



Т. о., поверхность С. к. отделяет события, к-рые могут находиться в причинной связи с O, от событий, для к-рых это невозможно, — с этим связано фундам. значение понятия «С. к.». Наблюдатель, находящийся в O, может знать только о событиях в области II и воздействовать только на события в области I.

При наличии полей тяготения пространство-время искривлено и мировые линии, образующие поверхность С. к., уже не являются прямыми; свойства С. к. вблизи вершин такие же, как в частной теории относительности, но в целом они могут отличаться.

СВЕТОВОЙ ПОТОК — световая величина, оценивающая поток излучения, т. е. мощность оптич. излучения, но вызываемому им световым ощущением, точнее, но его действию на селективный приёмник света. спектральная чувствительность к-рого определяется ф-цией относительной спектральной световой эффективности излучения $V(\lambda)$ (λ — длина волны света в вакууме). Единица С. п. — люмен. С. п. Φ_e связан с потоком излучения Φ_e соотношением

$$\Phi_e = K_m \int_0^\infty (d\Phi_e/d\lambda) V(\lambda) d\lambda,$$

где K_m — макс. значение спектральной световой эффективности, равное ≈ 683 лм/Вт (при длине волны 555 нм). И. Ю. Новбары.

СВЕТОВОЙ ПРОВОД — то же, что оптический провод, — см. в ст. *Оптические разряды*.

СВЕТОВОЙ ПУЧОК — совокупность световых лучей, испускаемых элементом поверхности источника dS в пределах малого телесного угла $d\Omega$. Если яркость поверхности источника равна I , а ось пучка и нормаль к dS совпадают, то поток энергии, переносимой С. п., равен $d\Phi = I dS d\Omega$.

СВЕТОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ — система *редуцированных фотометрических величин*, характеризующих свет в процессах его испускания, распространения и преобразования (отражение, пропускание и пр.). С. в. опре-

Основные световые величины

Величина	Обозначение	Связь с др. величинами	Единица	
			наименование	обозначение
Световой поток	Φ_e	$Q = \int \Phi_e dt$	люмен	лм · с
Световая энергия	Q	$K = \Phi_e / \Phi_e$	люмен на Ватт	лм · с · Вт ⁻¹
Световая эффективность излучения	K	$I = d\Phi_e / d\Omega$	кандела	кд
Сила света (источника в ненорм. направлении)	I	$L = \frac{d^2\Phi_e}{d\Omega d\Omega}$ $= -dA \cos \theta d\Omega$	кандела на квадратный метр (устаревшее назв., нит)	кд · м ⁻²
Яркость (в заданной точке и в заданном направлении)	L	E = $d\Phi_e / dA$	люкс	лк
Освещённость (в точке поверхности)	E	M = dQ_e / dA	люмен на квадратный метр	лм · м ⁻²
Светимость (в точке поверхности)	M	$H = dQ_e / dA = \int Edt$	люкс-секунда	лк · с
Экспозиция (световая экспозиция)	H	$\theta = \int Idt$	кандела-секунда	кд · с
Осветляющая способность	θ	$X_\lambda = dX/d\lambda$	—	—
Осветляющая плотность световой величины	X_λ			

Примечание. Вирево при Φ_e указывает на принадлежность Φ_e к системе световых величин, в отличие от энергетич. величины Φ_e (поток излучения). I — время; $d\Omega$ — элементарный телесный угол, в к-ром распространяется излучение; dA — площадь элемента поверхности; θ — угол между нормалью и элементом поверхности и направлением распространения излучения; X — любая световая величина.

делают по отношению к т. н. ср. человеческому светоадаптированному глазу (см. *Зрение*). Относительной спектральной чувствительностью этого условного приёмника света сдвигают ф-цию относительной спектральной световой эффективности, нормализованную в результате асперим. статистич. исследований (в них усреднение проведено как по большой совокупности глаз отд. людей с нормальным зрением, так и по реакциям глаз одного и того же человека в разл. моменты времени). В табл. приведены осн. С. в. и единицы С. в. в *Международной системе единиц* (СИ). Их определение см. в соответствующих статьях, напр. в ст. *Световой поток*, *Люмен*. Д. Н. Лазарев.

СВЕТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ — единицы световых величин: силы света, освещённости, яркости, светового потока и т. д. Единица силы света — *кандела* (кд, ранее — свеча); она воспроизводится по *световой эталону* и входит в качестве осн. единицы в Международную систему единиц (СИ). С. е. в этой системе приведены в табл. в ст. *Световые величины*. Употребляется также др. единицы освещённости и яркости: $1 \text{ фот} = 10^4 \text{ люкс}$; 1 люмен на квадратный фут (лм/фут² или 1 фут-свеча) = $= 10,764 \text{ люкс}$; $1 \text{ стильб} = 10^8 \text{ кд/м}^2$; $1 \text{ ламберт} = 10^4 \text{ лк/м}^2$; $1 \text{ фут-ламберт} = 3,426 \text{ кд/м}^2$. Д. Н. Лазарев.

СВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ — количество, определения, определения, характеризующих *оптическое излучение*, оптич. свойства материалов (прозрачность, отражательную способность) и пр. С. я. производится приборами, в составе к-рых входят приёмники света. В простейших случаях в диапазоне видимого света приёмником, с помощью к-рого оцениваются *световые величины*, служат человеческий глаз. Подробно о С. и. см. в ст. *Фотометрия*.

СВЕТОВЫЕ ЭТАЛОНЫ — меры для воспроизведения, хранения и передачи световых единиц, обеспечивающие единство световых измерений с наивысшей достижимой точностью. В качестве С. э. в разное время применялись: пламя свечи или лампы с заданными характеристиками (размеры пламени, вид топлива, скорость сгорания и пр.); 1 см^2 поверхности платины при темп-ре затвердевания; электрич. лампы накаливания. Различают первичные и вторичные С. э. Первичный С. э. единицы силы света (канделы) был осуществлён в национальных лабораториях 8 стран в виде т. н. полного излучателя, обладающего свойствами *абсолютно чёрного тела*, при темп-ре затвердевания платины (2045 К). Его яркость $6 \cdot 10^8 \text{ кд/м}^2$ международная согласованности ок. 0,6% при визуальной лабораторной погрешности $\pm 0,2\%$. Этот С. э. действовал по международному соглашению с 1948 по 1979. В 1979 решением Международного комитета по световым стандартам принято новое определение *кандела*, устанавливающее её связь с ваттом монохроматич. излучения вне зависимости от способа воспроизведения. Вторичные С. э. для единиц силы света и освещённости и для единицы светового потока представляют собой группы светоизмерит. ламп накаливания различного устройства и разной цветовой темп-ры. В. Е. Карпачевская.

СВЕТОДАЛЬНОМЕР — прибор для измерения расстояний по времени прохождения его оптич. излучением (светом). С. содержит источник оптич. излучения, устройство управления его параметрами, передающую и приёмную системы, фотоприёмное устройство и устройство измерения временных интервалов.

С. разделяются на импульсные и фазовые в зависимости от методов определения времени прохождения оптич. излучением расстояния до объекта и обратно (см. *Светоальтометрия*). Импульсные методы (методы с непосредств. измерением времени распространения) позволяют получать достаточно высокую точность (единицы и десятки см) только в случае усреднения большого числа измерений.

В импульсных С. источником излучения обычно являются твердотельные и полупроводниковые лазеры, работающие в ближнем ИК-диапазоне (0,8—1,06 мкм), излучение к-рых формируется в виде коротких импульсов. Медленно меняющиеся расстояния измеряются с помощью одиночных импульсов; при быстро меняющихся расстояниях применяется непрерывно-импульсный режим излучения. Твердотельные лазеры допускают частоту следования импульсов излучения до 50—100 Гц, полупроводниковые — до 10^4 — 10^6 Гц. Короткие импульсы (20—40 нс) твердотельных лазеров формируют в режиме модуляции добротности с помощью различного рода *оптических затворов*. В полупроводниковых лазерах генерация коротких импульсов мощностью до сотен Вт осуществляется путём формирования коротких импульсов тока накачки.

Импульсные С. используются в основном для измерения расстояний (сотни м — десятки км) до диффузно-рассеивающих объектов с точностью до единиц м.

В фазовых С. в качестве источников излучения применяются, как правило, светодиоды, непрерывные газовые лазеры (He — Ne, He — Cd, CO₂) либо полупроводниковые лазеры с мощностью излучения в единицы мВт.

Обычно модуляция гармонич. сигналом оптич. излучения газовых лазеров осуществляется внеш. электропит. или акустооптич. модуляторами на частотах до десятков и сотен МГц, а модуляция полупроводниковых излучателей — током накачки. Фазовые С. обеспечивают дальность действия при работе с оптич. отражателем на объекте от единиц до десятков км, а при диффузном отражении от объектов — до сотен м.

В качестве фотоприёмников чаще всего применяются фотодиоды или фотоумножители. Из-за нестабильности электронных элементов фазовый сдвиг сигналов за время измерений подвергается дрейфу. Для его учёта в С. включается линия оптич. короткого замыкания — система зеркал и призм или световодов, по к-рой модулиров. свет направляется из передатчика в приёмник, минуя измеряемую дистанцию. Измерение разности длин внеш. и внутр. дистанция позволяет учитывать и компенсировать ошибку за счёт дрейфа масштабной частоты. Большинство совр. С. построено по гетеродинной схеме с измерением разности фаз на взаимно промежуточной частоте, что позволяет автоматизировать процесс измерений с использованием цифровых методов. При этом разность фаз между опорным и измерит. сигналами представляется в виде последовательности импульсов, число к-рых подсчитывается.

Совр. С. по назначению и техн. параметрам условно можно разделить на три группы: для измерения больших расстояний (до 50 км) с ошибкой измерения 5—20 мм; для измерения малых расстояний (до 10—15 км) с ошибкой измерения 5 ± 10 мм; предельно-точные С. с ошибкой измерения 0,3—0,5 м и дальностью до 0,1—1 км. Нек-рые совр. С. представляют собой светоальтомерные насадки на теодолит, что расширяет круг решаемых прибором задач.

Объединение дальномерной и угломерной частот в единую конструкцию выделило отд. группу приборов — электронные тахеометры, представляющие собой комбинации электронного теодолита, светоальтомера и микропроцессора. В отд. класс выделяются двухволновые С., позволяющие измерять расстояния (с коррекцией влияния атмосферы) дисперсионным методом определения среднего вдоль трассы показателя преломления воздуха.

Лит. см. при ст. *Светоальтометрия*.

Ю. В. Попов, В. Б. Волконский.

СВЕТОДАЛЬНОМЕТРИЯ — измерение расстояний по времени распространения оптич. излучения (света) от источника излучения до объекта, отражающего или рассеивающего это излучение, и обратно. При этом измеряемое расстояние $d = ct/2$, где t — время про-

хождения сигналом двойного измеряемого расстояния, n — ср. значение показателя преломления среды (обычно воздуха), в k -ой распространяется сигнал.

Идея С. была высказана А. А. Майкельсоном (А. A. Michelson), первый светодальномер был реализован А. А. Лебедевым в 1936. Большое развитие С. получила после разработки лазеров.

Величина d может измеряться импульсным или фазовым методом. В первом случае излучение посылается короткими импульсами и измеряется непосредственно временной интервал t между вылученным сигналом $S(t)$ и принятым сигналом $S(t - \tau)$. Устанавливается критерий отсчета начала и конца временного интервала по определенным (пороговым) параметрам импульсов, напр. по фронту импульса или энергии, максимуму. Этот порог должен быть достаточно высоким, чтобы превышать шум. Собственно измерение интервала времени между посланным и отраженным импульсами осуществляется аналоговыми или цифровыми методами. В аналоговом измерителе временной интервал преобразуется в амплитуду напряжения. В цифровом методе интервал времени определяется по числу импульсов тактового генератора, прошедших по счетчику за этот интервал времени.

Импульсная лазерная С. при длительности импульсов излучения 20—40 нс имеет ошибку измерения неск. м. Применение систем с накоплением сигнала даёт ошибку менее 1 м. При энергии излучения в импульсе ок. 0,3 Дж достигается дальность действия по протяженным объектам до 20 км.

Лазерная импульсная С. применяется для измерения высоты облаков, высот полёта летательных аппаратов при аэрототсёмке, для точного определения орбиты ИСЗ, снабжённого угловым отражателем, и т. д.

В фазовом методе непрерывное излучение модулируется (напр., по синусоидальному закону) с высокой частотой ω и значение t определяется по запаздыванию фазы принимаемого отражённого излучения по отношению к фазе испускаемого (опорного). Измерения проводят след. образом. На входы фазометра поступают опорный сигнал с выхода генератора синусоидальных колебаний $E_1(t) = E_1 \sin(\omega t)$ и сигнал с выхода фотоприёмника (прошедший измеряемое расстояние) $E_2(t) = E_2 \sin(\omega(t - \tau) - \varphi)$, где $\varphi = 2\pi d/c + \varphi_0$ (φ_0 — фазовый сдвиг, вносимый измерит. установкой). Для частот модуляции ω , соответствующая длина волны k -рых $\lambda_m > 2d$, измеренное значение τ (за вычетом фазового сдвига φ_0) однозначно определяет расстояние d . Выполнив условия $\lambda_m > 2d$ противоречит получению высокой точности на больших расстояниях, т. к. для этой цели необходимо повышать частоту модуляции. Для $\lambda_m < 2d$ следует учитывать полное число N волн модуляции, укладывающихся на интервале $2d$. При этом

$$2d = \lambda_m(N + \delta/2\pi), \quad (*)$$

где δ — разность фаз, измеряемая фазометром. Устранить неоднозначность в (*) можно использованием неск. частот модуляции (т. н. фиксированных частот. При плавном изменении частоты, напр. по линейному закону, учитывается число нулевых значений фазового сдвига на выходе фазометра при изменении частоты модуляции в заданном интервале частот от ω_{\min} до ω_{\max} .

Реальное макс. расстояние, k -рое можно измерить светодальномером, зависит от дальности действия прибора, определяемой как расстояние, на k -ром мощность принимаемого сигнала равна пороговому значению. Пороговая чувствительность определяется заданной ошибкой (или точностью) измерения временного интервала или разности фаз и способом регистрации сигнала и может быть рассчитана для каждой конкретной дальномерной системы.

Наличие атмосферы приводит к ослаблению и рассеиванию оптич. излучения, что уменьшает дальность действия и понижает точность измерений. Кроме того, атмо-

сфера уменьшает скорость распространения эл.-магн. волны по сравнению с вакуумом, поскольку для оптич. диапазона показатель преломления воздуха в каждой точке является ф-цией длины волны излучения, температуры, давления и влажности. Это существенно ограничивает точность светодальномерных измерений. Скорость распространения оптич. излучения в атмосфере $\langle v \rangle = c/\langle n \rangle$, где $\langle n \rangle$ — среднестатистический показатель преломления:

$$\langle n \rangle = d^{-1} \int_0^d n(x) dx.$$

Для определения $\langle n \rangle$ необходимо измерить метеопараметры в достаточно большом кол-ве отд. точек. Точность измерения можно повысить с помощью дисперсионного метода, в k -ром измеряются не метеопараметры, а разность оптич. путей для двух разл. длин волн света, зависящая от $\langle n \rangle$. Двухволновый дисперсионный метод по измерениям в конечных точках может обеспечить точность $\langle n \rangle$ до 10^{-7} .

Учитывая все источники ошибок и принимая во внимание повышение инструментальной точности за счёт многократных измерений, результирующую ошибку измерений расстояний довер. светодальномерами с частотами модуляции до неск. десятков МГц можно довести до величин $m_d = \pm(3-10) + 1 \cdot 10^{-6} d$ мм. В прецизионных светодальномерах, где применяются частоты модуляции в сотни МГц, инструментальная ошибка составляет для d мм.

Фазовая С. применяется для бесконтактного измерения расстояний, в основном в топографо-геодезич. работах, в гляциологии, при измерении крупногабаритных деталей в машиностроении, при измерении и калибровке профиля радиотелескопов и др. Дифференцирование данных о расстоянии до объекта как в фазовой, так и в импульсной С. позволяет получить значимые радиальной скорости его перемещений (светодальномерные системы стыковки в космосе).

Развивается новое направление С. — лазерная профилометрия, k -рая на основе непрерывного измерения расстояния позволяет осуществлять автоматич. детальную регистрацию профиля разл. объектов, в т. ч. профиля земной поверхности. Светодальномерный профилометр применим для автономного ориентирования планетоходов.

Лит.: Вафиадис В. Г., Полюев Ю. В. Скорость света и ее значение в науке и технике, Минск, 1970; Волков И. В., В. В. Игольцев В. В., Высокочастотные светодальномеры для геофизии, гидрогеологии и машиностроения, «Труды ГОИ», 1985, т. 58, в. 192, с. 217; Радиогеодезические и электрооптические измерения, М., 1985; Мускелов Н. М., П. М. и И. И. Н. Д., Оптико-электронные системы ближней дальности, М., 1981. Ю. В. Полюев, В. В. Волковский.

СВЕТОДИОД — полупроводниковый диод, излучающий свет при пропускании тока через p — n -переход в прямом направлении. Физ. основу работы С. составляют процессы инжекции неосвоенных носителей заряда в активную область p — n -структуры и излучат. рекомбинации инжектиров. носителей (см. *Рекомбинация и осетель заряд*).

С. включает в себя активный элемент из полупроводникового монокристалла, в основном в виде кубика («чипа»), содержащего p — n -переход или *гетеропереход* и омич. контакты. Типичные размеры чипа: $0,3 \times 0,3 \times 0,25$ мм. С. содержит также элементы конструкции, предназначенные для сбора излучения, выпущенного внеш. оптич. эффективностью и формирования необходимой диаграммы направленности излучения. С. может иметь два чипа с разл. цветами свечения или один чип с двумя p — n -переходами, излучающими в двух спектральных полосах. В этом случае возможно управление цветом свечения. С. может содержать также резистор или микросхему, позволяющие управлять питающим напряжением С. (см. *Интегральная схема, Микроэлектроника*). С. могут иметь усложнённую кон-

струкцию, повышающую эффективность ввода излучения в волокно, если они предназначены для использования в СЕЦ, цепях, напр. в волоконно-оптич. линиях связи (ВОЛС) (см. *Волокнонная оптика*).

С. характеризуются высокой яркостью (тыс. кд/м²), силой света (до десятков кд), силой излучения (сотни мВт/ср), внеш. квантовым выходом излучения (до 50%), широким спектральным диапазоном ($\lambda_{\text{макс}} \approx 7-0,35$ мкм), высоким быстродействием (до единиц нс), совместимостью по входным характеристикам с транзисторными микросхемами, а по спектру излучения С. ИК-диапазона — с фотоприёмниками на основе кремния, ВЧ-диапазона — моголитной интеграции, возможностью ВЧ-модуляции излучения путём модуляции тока накачки (до сотен МГц), низковольтностью электропитания (1,5—4 В), надёжностью и большим сроком службы (до сотен тыс. ч).

Основные механизмы возбуждения светодиода — инжекция носителей заряда и ударная ионизация. Инжекция наиб. эффективна в гетероструктурах (ГС). Вследствие разрывов в валентной зоне и зоне проводимости гетероперехода при смешении перехода в прямом направлении наблюдается односторонняя инжекция носителей заряда из широкозонного материала в узкозонный практически независимо от уровня легирования n - и p -областей. В двойных гетероструктурах (ДГ) вследствие эффекта электронного ограничения (см. *Гетероструктура*) повышается концентрация носителей в активной области структуры. Если толщина активной области $d < L$, где L — диффузионная длина инжекторов, носителей, то концентрация носителей в L/d раз превышает концентрацию в гомоструктуре при том же уровне возбуждения. Применение ДГ позволяет повысить внеш. квантовый выход излучения ($\eta_{\text{вн}}$) при малых токах накачки. Ударная ионизация имеет место при обратном смешении p — n -перехода до напряжения электрич. пробоя. Этот механизм введения неравновесных носителей менее эффективен, чем инжекционный.

Излучат. рекомбинация в С. осуществляется в прямозонных полупроводниках (напр., GaAs, InAs, твердых растворах GaAs_{1-x}P_x при $x < 0,4$, Ga_{1-x}Al_xAs при $x < 0,35$ и др.), в k -рых абс. минимум зоны проводимости находится при том же значении квазимимума, что и максимум валентной зоны. Переход электрона с сохранением квазимимпulses характеризуется высокой вероятностью и является излучательным. Длина волны излучения в максимуме спектральной полосы определяется шириной запрещённой зоны E_g по примерно соотношению $\lambda_{\text{макс}} \approx 1,239/E_g$. Полное число излучат. переходов R в единице объёма пропорц. концентрации электронов (n) и дырок (p) в активной области: $R = B_n p$, где B_n — коэф. рекомбинации, равный для прямозонных полупроводников $\sim 10^{10}$ см³/с.

С. на основе гомопереходов в прямозонных полупроводниках, легированных т. в. мелкими примесями (см. *Примесные уровни*), имеют существен. недостаток — сильное поглощение излучения внутри кристалла (коэф. поглощения $\alpha \sim 10^4$ см⁻¹). Снижение потерь на межзонное поглощение достигается уменьшением энергии излучения за счёт компенсации примесей в активной области (напр., в эпитаксиальной p — n -структуре GaAs, легированной Si). При сильном легировании и компенсации хаотически расположенный в пространстве заряд примесей создаёт искривление границ зон, при k -ром локальная ширина запрещённой зоны остаётся постоянной (см. *Сильнолегированный полупроводник*). Это приводит к тому, что в распределении плотности состояний появляются участки при энергиях ниже зоны проводимости и выше валентной зоны — т. в. хвосты плотности состояний, пространственно разделённые в обеих зонах. В С. с такой структурой в излучат. рекомбинации принимают участие глубокие и удалённые группы состояний. При этом излучаемые фотоны характери-

зуются энергией, меньшей E_g , на глубину потенциальных ям ΔE : $h\nu_{\text{изл}} \approx E_g - 2\Delta E$, и поэтому способны поглощаться в кристалле ($\alpha \approx 100$ см⁻¹). Одновременно эти переходы имеют высокую иерированность (быстродействие С. примерно 0,5—1,5 мкс), т. к. плотность состояний на две потенциальных ямы мала. В связи с низким коэф. поглощения внеш. квантовый вход излучения для приборов с полусферич. кристаллом достигает $\eta_{\text{вн}} \approx 28\%$.

В непрямозонных полупроводниках k — k (GaP, GaAs_{1-x}P_x при $x > 0,4$ и др.) афф. излучательная рекомбинация может осуществляться только при наличии определённого примесного центра, фотоэлектронно замещающего один из атомов соединения. Роль этого центра заключается в том, что на нём образуется связанный экситон. Например, для GaP таким центром являются N, обуславливающий зелёное свечение, и комплекс Zn — O, обуславливающий красное свечение. Азот в GaP фотоэлектронно замещает P. Ввиду того что N имеет меньший ат. номер, чем P, меньший ионный радиус и отличается по электроотрицательности, то образовавшийся нейтральный центр притягивает электрон короткодействующими силами. После захвата электрона дырка притягивается к заряд. центру кулоновскими силами и реализуется излучат. переход. Этот аксионный излучат. переход обуславливает бесфононную линию A и её фононные повторения в спектре излучения.

В непрямозонных полупроводниках наблюдается также афф. доворно-акцепторная рекомбинация, при k -рой носители захватываются на свои примесные центры, а затем электрон переходит с дотора на акцептор в акте излучат. рекомбинации. Примером может служить рекомбинация на доторно-акцепторной паре Al — N в 6H — SiC и 4H — SiC, приводящая к излучению синего ($\lambda_{\text{макс}} \approx 480$ нм) и фиолетового ($\lambda_{\text{макс}} \approx 423$ нм) свечения.

Для осуществления прямых переходов при большей ширине запрещённой зоны, чем дают бинарные соединения GaAs, InP и др., применяют трёхкомпонентные твёрдые растворы прямозонных бинарных соединений

с малой E_g и непрямозонных бинарных соединений с большой E_g . Примером такого соединения является GaAs_{1-x}P_x, для k -рого Γ -минимум прямых переходов расположен ниже X -минимума непрямых переходов (см. *Зонная теория*) в значительной области составов. Твёрдые растворы GaAs_{1-x}P_x и Ga_{1-x}Al_xAs сохраняют преим. прямые переходы до энергий, соответствующих красному цвету свечения, а твёрдые растворы Ga₂In_{1-x}P и Al₂In_{1-x}P — до энергий, соответствующих жёлтому и зелёному цветам свечения (рис. 1).

В целях расширения спектрального диапазона излучения применяют также четверные соединения с изовалентным замещением одновременно элементов III и V групп периодической системы элементов. Примером является соединение Ga₂In_{1-x}P₂As_{1-x}, позволяющее получить излучение в важном для ВОЛС диапазоне длин волн: $\lambda_{\text{макс}}$ равна 1,3 и 1,5 мкм.

Для снижения потерь света на поглощение внутри кристалла С. используют широкозонное окно, k -рое позволяет вывести свет из активной области гетерострук-

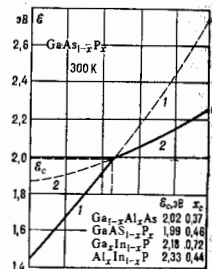


Рис. 1. Минимумы зоны проводимости GaAs_{1-x}P_x для прямого (Γ , кривая 2) и непрямом (X , кривая 1) переходов в зависимости от состава твердого раствора.

туры через широкозонный эмиттер без потерь на межзонное поглощение.

Переизлучение света, излучаемого в направлении к подложке, в спец. фотолитоисцентном слое, ширина запрещенной зоны к-рого меньше или равна ширине запрещенной зоны активной области, позволяет в 2—2,5 раза повысить $\eta_{\text{вн}}$. Эти гетероструктуры (рис. 2)

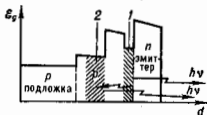


Рис. 2. Схематическое изображение изменения ширины запрещенной зоны гетероперитансильных ФЭЛ-структур: 1 — область излучательной рекомбинации; 2 — область переизлучения.

называют фотоэлектролюминесцентными (ФЭЛ-структурами).

В ДГ, содержащей активную узкозонную область, заключенную между двумя широкозонными эмиттерами, прозрачными для генерируемого излучения, и не содержащей поглощающий свет подложки (т. е. многопроходные двойные гетероструктуры, МДГ), фотоны, отразившись от поверхности внутрь кристалла, могут после многократных отражений ввести вклад в выходящее излучение. При этом потеря фотонов на поглощение в активной области $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ не наблюдается в связи с тем, что поглощение происходит с переизлучением, квантовый выход к-рого близок к 1. Многопроходность приводит к резкому возрастанию $\eta_{\text{вн}}$. Так, в С. на основе МДГ $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ (рис. 3) достигнут $\eta_{\text{вн}} = 21\%$ в красной области спектра и 38% в ИК-диапазоне.

Для снижения потерь света на полное внутреннее отражение на границе полупроводника с окружающей средой применяют следующие меры. 1) Выполняют кристалл в виде полусферы или усеченной сферы (сферы Вейерграсса); в этом случае размер r — перехода существенно меньше диаметра полусферы; 2) помещают кристалл в среду с показателем преломления $n_{\text{возд}} < n < n_{\text{п}}$ для увеличения критич. угла (напр., использование прозрачного оксидного компаунда с $n = 1,5-1,6$ увеличивает выход излучения из кристалла в 2,5—3 раза); 3) применяют

Характеристики светодиодов

Излучающая структура и подложка	Цвет свечения	$P_{\text{выход}}$, мВт	Квантовый выход, $\eta_{\text{вн}}$, макс. значение	Сила света $I_s \cdot 10^{-4}$ кд при токе 20 мА, макс. значение
ГС $\text{Ga}_{0,52}\text{Al}_{0,48}\text{As}$ As/GaAs	красный	860	6	500
ДГ $\text{Ga}_{0,48}\text{Al}_{0,52}\text{As}$ As/GaAs	—	—	—	1000
МДГ $\text{Ga}_{0,48}\text{Al}_{0,52}\text{As}$ As/GaAlAs	—	—	21	5000
$\text{GaAs}_{0,52}\text{P}_{0,48}$ N/GaP	оранжевый	630 ± 5	0,6	300
$\text{GaAs}_{0,48}\text{P}_{0,52}$ N/GaP	желтый	585 ± 5	0,25	200
GaP GaP/N/GaP	желто-зеленый	565 ± 2	0,5	400
GaP SiC/SiC—6H	зеленый	555 ± 1	0,2	200
SiC SiC/SiC—4H	синий	480	0,04	12
	фиолетовый	423	0,001	1
GaAs Si/GaAs	ИК-излучение	930 ± 10	28	—
ДГ $\text{Ga}_{0,5}\text{Al}_{0,5}\text{As}$ As/GaAs	—	850 ± 30	7	—
МДГ $\text{Ga}_{0,5}\text{Al}_{0,5}\text{As}$ As/GaAlAs	—	—	38	—

Рис. 3. Схематическое изображение изменения ширины запрещенной зоны МДГ в системе $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$.



плоские кристаллы с мезаструктурой, позволяющие за счёт внутр. фокусировки излучения повысить выход излучения в 2—3 раза; 4) создают диффузно-рассеивающую излучающую поверхность, улучшающую условия вывода излучения для лучей, падающих на границу раздела под углом, большим критического; это позволяет повысить выход света в 1,5—2 раза.

Быстродействие излучающих диодов или предельная частота модуляции излучения ограничивается временем жизни неосновных носителей:

$$P_{\text{вн}}/P_0 = [1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2}$$

где P_0 — мощность излучения на частоте ω , $P_{\text{вн}}$ — мощность немодулированного излучения, τ — время жизни неосновных носителей. Время нарастания и спада излучения по уровням 0,1—0,9 для С. на высокоэффективных МДГ в системе $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ с красным и ИК-излучением составляет 15—25 нс.

Технология светодиода основана на использовании эпитаксиальных методов: жидкостной эпитаксии, газотранспортной эпитаксии, МОС-гидридной эпитаксии.

Обобщенные данные по характеристикам светодиодов приведены в табл., а типичные спектры излучения — на рис. 4.

Области применения: сигнальная индикация, подсветка постоянных надписей, отображение мнемонич. информации, блоки матриц бесшовой ст-

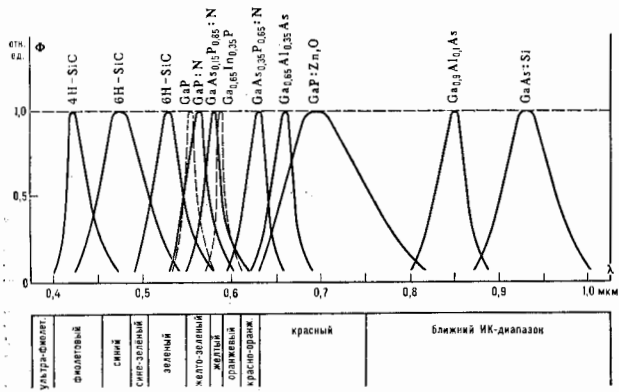


Рис. 4. Типичные спектры излучения светодиодов.

ковки для создания бегущих строк и экранов большой площади, устройства дистанц. управления битовой и промышленной радиоаппаратурой на основе С. ИК-диапазона, излучатели для ВОЛС, для медицинских приборов, для газоанализа и влагометрии, линейки С. для копирования и считывающих устройств персональных компьютеров, анализаторов изображения, оптопары и разобщённые оптроны в автоматике, устройства бесконтактного измерения углов между поверхностями, угл. перемещений и угл. скоростей, параметров вибрации, ухода гидроприборов и т. п.

Лит.: Берг А., Дин П., Светодиоды, пер. с англ., М., 1979; Коган Л. М., Полупроводниковые световозвращающие диоды, М., 1983; Ishihata S., Okuno Y., High efficiency GaAlAs, LED, «Optoelectronics - Devices and Technol.», 1989, в. 4, № 1, p. 21; Коган Л. М. и др., Новые световозвращающие диоды, «Электрон. промышленность», 1990, № 9, с. 22.

СВЕТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ДРЕЙФ газов и газоподобных сред — относят. движение (дрейф) компонентов газовой смеси, возникающее при резонансном взаимодействии излучения с одним из компонентов смеси. С. д. обусловлен селективным по скоростям возбуждением резонансно поглощающих излучение частиц и различием транспортных характеристик возбуждённых и невозбуждённых частиц при их столкновениях с др. компонентами смеси [1].

Впервые С. д. атомов наблюдался в 1979 [2], молекул — в 1981 [3]. С. д. возможен и в средах, подобных газам, напр. для электронов проводимости в твёрдых телах [4; 5] (экспериментально зарегистрирован в 1983 [6]).

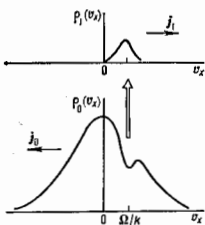
Физ. основу С. д. легко пояснить на примере простейшей модели двухуровневых частиц, резонансно поглощающих излучение бегущей монохроматич. волны и находящихся в среде буферного (не взаимодействующего с излучением) газа. С учётом доплеровского уширения с излучением взаимодействуют только те частицы поглощающего газового компонента, скорости к-рых в находятся в окрестности «резонансного» значения, определяемого соотношением:

$$\Omega \approx \omega - \omega_{10} = kv, \quad (1)$$

где ω — частота излучения, ω_{10} — частота резонансного перехода между основным (0) и возбуждённым (1) состояниями, k — волновой вектор излучения.

Под действием излучения происходит селективное по скорости изменение асимметрии основного ($\rho_0(v_x)$) и возбуждённого ($\rho_1(v_x)$) состояний поглощающих частиц. На рис. показано характерное распределение асимметрий $\rho_0(v_x)$ и $\rho_1(v_x)$ по проекции v_x скорости на волновой вектор (ось z) без учёта столкновений и в предположении, что при поглощении фотона скорость частицы не меняется (последнее означает пренебрежение эффектом светового давления, что заведомо оправдано в специфич. для С. д. условиях). В первоначально равновесном (максвелловском) распределении $\rho_0(v_x)$ излучение создаёт «провал» в окрестности резонансной скорости $v_x = \Omega/k$, образуя неравновесное распределение $\rho_1(v_x)$ возбуждённых частиц при тех же значениях v_x . Неравновесным распределением $\rho_1(v_x)$ и $\rho_0(v_x)$ соответствуют отличные от нуля встречные парциальные потоки частиц:

Распределение асимметрий по скоростям при селективном оптическом возбуждении; j_0, j_1 — встречные парциальные потоки.



Распределение асимметрий по скоростям при селективном оптическом возбуждении; j_0, j_1 — встречные парциальные потоки.

в специфич. для С. д. условиях). В первоначально равновесном (максвелловском) распределении $\rho_0(v_x)$ излучение создаёт «провал» в окрестности резонансной скорости $v_x = \Omega/k$, образуя неравновесное распределение $\rho_1(v_x)$ возбуждённых частиц при тех же значениях v_x . Неравновесным распределением $\rho_1(v_x)$ и $\rho_0(v_x)$ соответствуют отличные от нуля встречные парциальные потоки частиц:

$$j_{1,0} = -\frac{k}{k} \int v_x \rho_{1,0}(v_x) dv_x. \quad (2)$$

Т. о., излучение способно индуцировать встречные парциальные потоки возбуждённых и невозбуждённых частиц. В отсутствие столкновений с буферным газом суммарное распределение по скоростям $\rho_0(v_x) + \rho_1(v_x)$ остаётся максвелловским. При этом потоки j_1 и j_0 полностью компенсируют друг друга, так что газ поглощающих частиц как целое покоится.

Ситуация радикально меняется, как только начинают проявляться столкновения поглощающих частиц с частицами буферного газа. Порождённые излучением встречные потоки j_0 и j_1 испытывают торможение в буферном газе. Силы торможения (внутр. трения) $F_{1,0}$ направлены против потоков и пропорциональны им:

$$F_{1,0} = -m v_{1,0} \delta j_{1,0}, \quad (3)$$

где m — масса частицы, $v_{1,0}$ — газокинетич. (транспортные) частоты столкновений. В общем случае транспортные характеристики для разных внутр. состояний частицы (основного и возбуждённого) различаются, поэтому $v_1 \neq v_0$. Вследствие этого различия и силы торможения потоков j_0 и j_1 , изначально одинаковых по величине. Поэтому становится отличной от нуля результирующая сила $F = F_0 + F_1$, действующая со стороны буферного газа на газ поглощающих частиц как целое. Эта сила и приводит к дрейфу поглощающего компонента относительно буферного, в чём и состоит эффект С. д.

Результирующую силу в соответствии с (3) можно представить в виде:

$$F = m[(v_0 - v_1)j_1 - v_0 j_0], \quad (4)$$

где j — результирующий поток поглощающих частиц. Поток j формируется в течение времени порядка времени свободного пробега и приобретает значение, определяемое условием $F = 0$. Представив j в виде $j = uN$, где u — скорость С. д., N — концентрация поглощающих частиц, из (4) находим

$$u = \frac{v_0 - v_1}{v_0} \cdot \frac{j_1}{N}. \quad (5)$$

В условиях большого доплеровского уширения и при редких столкновениях $j_1 = (\Omega/k)N_1$ (N_1 — концентрация возбуждённых частиц), при этом

$$u = \left(\frac{k}{k}\right) \frac{v_0 - v_1}{v_0} w_1 \frac{\Omega}{k}, \quad w_1 = N_1/N. \quad (6)$$

Параметр w_1 характеризует долю возбуждённых частиц. При снятии сделанных ограничений для скорости дрейфа справедливо выражение [7,8]:

$$u = \left(\frac{k}{k}\right) v_T \frac{v_0 - v_1}{v_0} \frac{\Gamma_1}{\Gamma_1 + v_1} w_1 \Phi. \quad (7)$$

Здесь v_T — наиб. вероятная тепловая скорость, Γ_1 — константа релаксации возбуждённого уровня, Φ — безразмерный фактор, отражающий специфич. (антисимметричную) зависимость скорости дрейфа от отстройки частоты Ω . В оптимальных условиях Φ достигает значения ~ 1 .

Дрейфовое движение коллинеарно волновому вектору и может осуществляться как в направлении распространения излучения, так и в обратном направлении в зависимости от знака Ω и знака разности $(v_0 - v_1)$ транспортных частот столкновений. При $\Omega = 0$ С. д. отсутствует. Если относит. изменение частоты столкновений при возбуждении достаточно велико ($|v_0 - v_1|/v_0 \sim 1$), что не является редкостью, по крайней мере, для электронных переходов атомов, то, подбирая эксперим. условия, можно достичь величин скорости дрейфа, сравнимой с тепловой скоростью.

Важно отметить принципиальную роль буферного газа. Эффект существует только в его среде и проявляется в виде относит. движения газовых компонентов при сохранении импульса газовой системы в целом. В отсутствие буферного газа, согласно закону сохранения импульса, поглощающий газ обязан оставаться в покое как целое.

Яркой особенностью С. д., отличающей его от др. эффектов воздействия излучения на движение частиц газа, является то, что для возникновения направленного движения газовых компонентов не обязательен прямой или косвенный обмен импульсом в энергетике между излучением и внеш. степенями свободы частиц газа. Особенно отчетливо это видно на примере сугубо радиационной релаксации возбуждённого состояния поглощающих частиц (что характерно для электронных переходов атомов); поглощённый частицей фотон в результате спонтанного испускания снова возвращается в поле излучения практически без изменения энергии. Т. о., энергия поступает движения газовых компонентов чередается из тепловой энергии, а действие излучения, выступающего в роли своеобразного «двигателя» Максвелла, состоит в преобразовании хаотич. (теплового) движения частиц газа в упорядоченное (направленное) движение компонентов смеси. Незабывное при этом уменьшение энтропии газовой подсистемы компенсируется увеличением энтропии второй подсистемы — излучения: из упорядоченного (направленного) оно преобразуется в изотропно рассеянное излучение в результате спонтанного испускания после акта поглощения.

Благодаря уникальным особенностям С. д. применяется в широких областях физики (неравновесной газовой динамике, физике атомных и молекулярных столкновений, физике твёрдого тела, ядерной физике и др.) и астрофизики (в частности, для объяснения феномена т. н. некулярных звёзд). Действие С. д. как селективного оплч. насоса оказывается полезным для ряда прикладных задач (разделение изотопов и ядерных элементов, в особенности короткоживущих, разделение ядерных спинового модификаций тяжёлых молекул, регистрация микропримесей и т. д.).

Лит.: 1) Гельмухьянов Ф. Х., Шалагина А. М., Светондуцированная диффузия газов, «Исследования», 1979, т. 29, с. 773; 2) АncyгиH В. Д. и др., Светондуцированная диффузия паров натрия, там же, 1979, т. 30, с. 262; 3) Панфилов В. Н. и др., Светондуцированный дрейф в равновесии компонентов смеси ^{133}Cs - ^{135}I в поле направленного ИК-излучения, там же, 1981, т. 33, с. 52; 4) Скоков М. М., Шалагина А. М., Светондуцированный дрейф электронов в полупроводниках, там же, 1980, т. 32, с. 204; 5) Дыхеев А. М. и др., Резонансное возбуждение фотонов в полупроводниках, «Доклады АН СССР», 1980, т. 264, с. 599; 6) Крайченко А. Ф. и др., Фотоод, индуцированная импульсом фотона при оптических переходах между уровнями Ландау, «Исследования в КФТФ», 1983, т. 38, с. 328; 7) Митроенко В. Р., Шалагина А. М., Светондуцированный дрейф многотронных систем, «Изв. АН СССР. Сер. физ.», 1981, т. 45, с. 995; 8) Rautila S. G., Shalagina A. M., Kinetic problems of non-linear spectroscopy, Amst.—Oxf., 1981.

СВЕТОКЛАПАННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР — электронно-лучевой прибор из группы проекционных приёмных электронно-лучевых приборов, в к-ром взаимодействие пучка электронов с двумерной мишенью обеспечивает пространственно-временную модуляцию широкого светового потока, внешнего по отношению к С. з.-л. п. источника света. Для реализации этого принципа используется неск. видов светомодулирующих сред, в к-рых под действием поля вносимых пучком зарядов изменяется к.-л. оптич. свойство: поглощение, преломление, дифракция, поляризация световых волн.

Один из принципов построения С. з.-л. п. связан с деформацией поверхности непроводящей или слабопроводящей мишени из вещества, обладающего малой вязкостью или высокой эластичностью. Деформация, к-рые возникают под действием сил притяжения между зарядами, наносимым пучком на поверхность мишени, и её проводящей подложки, изменяют ход световых лучей, что в сочетании с использованием систем щелей позволяет модулировать падающий на мишень свет (рис. 1). С помощью источника света 1 и линзы 3 первая система щелей 2 отображается в плоскости второй системы щелей 5, расположенной так, что свет, прошедший через щели первой, перехватывается «прутками» второй, если поверхность мишени 4 не де-

формирована. При возникновении деформаций под действием электронного пучка 7 часть света, тем большая, чем сильнее деформация, в результате преломления и дифракции проходит через щели 5. Изображение мишени проецируется объективом 6 со значительным увеличением на отдалённый внеш. экран (не показан). На

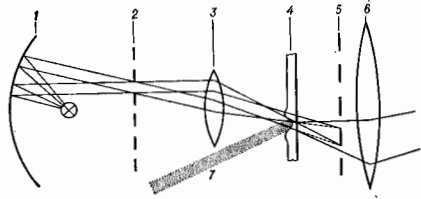


Рис. 1.

основе этого принципа при разл. модификациях оптич. схемы, работающих на просвет или на отражение, создан ряд устройств: телевизионный проектор «Эйфор» с непрямоугольной откаткой, в к-ром площадь проецир. экрана достигает 100 м², а светомодулирующей средой является обновляемая масляная плёнка; однолучевые отпаляющие монохромные и полноцветные проекторы с экраном 5—10 м², с такой же светомодулирующей средой; приборы с эластомерной или термопластич. мишенью.

Др. принцип работы С. з.-л. п. связан с эффектом наведённого двулучепреломления в неких одноосных электролитич. кристаллах с отсутствующим или компенсированным естеств. двулучепреломлением (Поккелев эффект). Если на мишень 6, представляющую собой такой кристалл (рис. 2), покрыта с одной стороны прозрачным проводящим слоем 5, а с другой — диэлектрич. зеркалом 7 и помещённая в

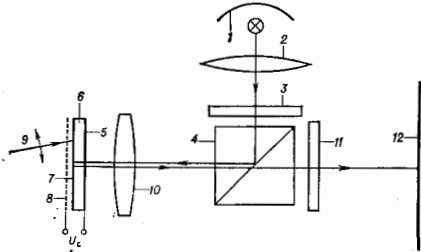


Рис. 2.

С. з.-л. п., направить поляризованный поляризатором 3 свет, излучаемый источником 1 и коллимированным конденсором 2, то в отсутствие электрич. напряжения на кристалле отражённый от зеркала 7 свет после прохождения светорасщепителя 4 не пройдёт через скрещённый с поляризатором 3 анализатор 11. Там, где сканирующий электронный пучок 9 вследствие изменения при подаче входного сигнала U_c условий отбора итеричных электронов на сетку 8 заряжает поверхность кристалла, из-за возникающего поля кристалл становится двухосным с наведённой разностью показателей преломления, пропорциональной напряжению на гранях кристалла. Это приводит к повороту плоскости поляризации и к

частичному прохождению света через анализатор 12, пропорциональному входному сигналу. Возможна оптич. схема, работающая на просвет. Наиб. эффективное преобразование достигнуто на кристаллах дидерфосфата калия KD_2PO_4 (условно — DKDP) вблизи их *K*-рассеяния ($\approx -52^\circ C$).

Практич. применение нашли С. з.-л. п., принцип действия к-рых основан на возникновении *д* и *е* в *т* в *о* г *л* о *ц* е *н* и *и* света в определённой области спектра при облучении электронами *ионных кристаллов*. В проходящем или отражённом широкополосном свете записанное пучком изображение выглядит окрашенным в доплит. цвет и может быть спроецировано на внеш. экран. Для стирания изображения необходим подогрев экрана С. з.-л. п. Такие приборы получали назв. *катодокр. приборов* или *скиатронов*.

Лит.: Мара Я. Ж., Дойчио и Ж., Ава и Ж.-П., Устройства воспроизведения изображений, основанные на эффекте Покемеля, и их применение, в сб.: Достижения в технике передачи и воспроизведения изображений, пер. с англ., т. 1, ч. 4, М., 1978.

СВЕТОЛОКАЦИЯ — то же, что *оптическая локация*.

СВЕТОПРОВООД — то же, что *световод*.

СВЕТОСИЛА — коэф. пропорциональности в выражении, связывающем фототермич. величину (*освещённость, световой поток*), измеряемую приёмником оптич. прибора и яркость источника. Во мн. случаях измеряемой величиной является освещённость *E* изображения. Если апертурная диафрагма круглая (как в большинстве приборов), то $E = V \sin^2 \mu$, где V — коэф. пропускания системы, V — яркость источника, и — апертурный угол объектива, т. е. угол, под к-рым радиус выходного зрачка объектива виден из центра изображения. Величина $\mu \sin^2 \mu$ наз. С. прибора. Если объект находится на бесконечности и оптич. система хорошо исправлена (см. *Синусов условие*), то $\mu \sin^2 \mu = D/2f$ (D — диаметр входного зрачка, f — его фокусное расстояние), а E может быть записан в виде $E = BV/S^2$, где S — площадь входного зрачка. Последняя ф-ла верна и в том случае, когда зрачок системы имеет произвольную форму, напр. форму кольца (в зеркально-лиазовых системах). Величину $\tau S^2/f^2$ часто называют физической или эффективной С., а величину S^2/f^2 — геом. С. оптич. системы. Если отнosit. отверстие объектива D/f обозначить через $1/K$, то $E = V \sin^2 4K^2$, т. е. С. обратно пропорциональна K^2 .

В сложных оптич. системах из-за больших потерь при отражении света от поверхностей линз и за счёт поглощения материалом линз коэф. пропускания τ очень мал (до 10% и даже меньше в сложных оптич. системах, напр. перископах). Поэтому физ. С. значительно меньше геометрической. Однако *просветляющие оптики* коэф. τ можно увеличить так, что физ. С. будет лишь немного меньше геометрической. В оптич. системах, удовлетворяющих условию синусов, величина D/f не может превосходить 2.

Лит.: Тудоровски Я. А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., т. 2, М.—Л., 1952; Теория оптических систем, 2 изд., М., 1981.

СВЕТОФИЛЬТР — устройство, меняющее спектральный состав и энергию падающего на него оптич. излучения; то же, что *оптический фильтр*.

СВЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — появление направленного электронного потока в твёрдом проводнике в результате передачи электронам импульса от направленного потока фотонов. Наблюдается в оптич. и СВЧ-диапазонах в нек-рых металлах, полупроводниках, полуметаллах в виде тока (того увеличения) или эдс. Наиб. исследован в полупроводниках (Ge, Si, соединения $A^{III}B^V$, см. *Полупроводниковые материалы*). Подробнее см. в ст. *Увеличение электронов фотонами*. **СВЕЧ4** — старое название единицы силы света СИ; совр. название — *кандела*.

СВИНЦ (Plumbum), Pb, — хим. элемент IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 82, ат. масса 207,2. Природный С. — смесь четырёх стабильных изотопов: ^{204}Pb (1,4%), ^{208}Pb (23,6%), ^{207}Pb (22,6%) и

^{206}Pb (52,4%), причём ^{208}Pb , ^{206}Pb и ^{207}Pb — последние (стабильные) члены природных радиоакт. рядов ^{232}Th , ^{238}U и ^{235}U соответственно; на определения содержания этих изотопов С. в природных рудах урана и тория основан метод определения абс. возраста горных пород. Как члены природных радиоакт. рядов в земной коре в ничтожных кол-вах присутствуют радионуклиды С.: ^{210}Pb ($T_{1/2} = 10,6$ ч), ^{214}Pb ($T_{1/2} = 26,8$ мин), ^{218}Pb ($T_{1/2} = 21$ год), ^{212}Pb ($T_{1/2} = 36,1$ мин). Электронная конфигурация внеш. оболочек $6s^2 6p^2$. Энергия первого ионизации 7,417; 15,032; 31,981; 42,32; 68,8 эВ соответственно. Атомный радиус 0,175 нм, радиус по Pb^{2+} 0,126 нм, Pb^{4+} 0,076 нм. Значение электроотрицательности 1,55.

В свободном виде С. — мягкий пластичный тяжёлый серевасто-серый металл, обладает гранецентриров. кубич. решёткой с параметром $a = 0,49502$ нм. Плотн. 11,340 кг/дм 3 , $t_{пл} = 327^\circ C$, $t_{кип} = 1745^\circ C$. (При давлении выше 13 ± 1 ГПа существует модификация, обладающая гексагональной плотнейшей упаковкой — т. в. С.-II.) Уд. теплоёмкость $c_p = 26,44$ Дж/(моль·К), теплота плавления 4,77 кДж/моль, теплота испарения 178,0 кДж/моль. Темп-ра Дебая 105,3—106,7 К. Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 7,19 К. Уд. электр. сопротивление 0,190 мкОм·м (при 0 $^\circ C$), термич. коэф. электр. сопротивления 4,2·10 $^{-4}$ К $^{-1}$. Теплопроводность С. 35,0 Вт/м·К (при 20 $^\circ C$), термич. коэф. линейного расширения (28,3—29,2)·10 $^{-6}$ (при 0—100 $^\circ C$). Поверхностное натяжение жидкого С. 480 мН/м (при 700 К). Диамагнитен, уд. магн. восприимчивость — 0,12·10 $^{-6}$. Д. С. чистой 99,998% при комнатной темп-ре модуль нормальной упругости 15,7 ГПа, т. в. по Бриллею 38—42 МПа. С. — высокопластичный металл, его стружку можно спрессовать в монолитное изделие при давлении ~200 МПа.

В хим. соединениях проявляет степени окисления +2 и реже +4. На воздухе металлич. С. быстро покрывается плёнкой оксида (С. тускнеет), предохраняющей его от дальнейшего окисления. С. устойчив к действию разбавленных серной и соляной кислот. С. металлами, характерными являются более низкой электроотрицательностью (Li, Na, Mg, Ca и др.), образует интерметаллич. соединения — *пьюмбиды*. Соединения С. *людиты*.

С. применяют для изготовления пластин аккумуляторов, для создания коррозионностойкой хим. и алотрохим. аппаратуры, для изготовления уплотнителей в вакуумной аппаратуре, как материал для защиты от ионизирующих излучений (связанные кирпичи, связное стекло — стекло с высоким содержанием Pb). Из С. изготавливают оболочки проводов и кабелей. С. входит в состав разл. сплавов (антифрикционных, типографских и др.), на основе С. изготавливают разл. припои (обычно содержат также Sn и Sb), широко используемые при пайке радиотехн. аппаратуры. С. входит в состав нек-рых полупроводниковых материалов.

С. С. Вербоосе.

СВИП-ГЕНЕРАТОР (от англ. sweep — развёртка, качение) — генератор сигналов «качающейся» частоты, используемый в радиотехнике вместе с электронным осциллографом для получения амплитудно-частотных характеристик разл. цепей (фильтров, цепей коррекции, усилителей и т. н.). Несущая частота С.-г. изменяется по пилообразному или треугольному закону. Её величина зависит от назначения прибора и может изменяться в широких пределах — от звуковых до СВЧ.

Ю. С. Константинов.

СВИСТКИ — механич. устройства для преобразования кинетич. энергии струи в энергию акустич. колебаний. В отличие от *сирен* не имеют вращающихся или движущихся частей, что делает их более пригодными при использовании в техпол. оборудовании. Принцип работы С. состоит в создании автоколеб. режима течения высокоскоростной струи путём её торможения полами резонатора или клином, снабжённым резонанс-

$\epsilon^2 = \Delta m^2$

В классической механике... системы. Действия сил были рассмотрены велики (см. Ломоносов как жидк., Иллюстрация). Кроме того, в потенциальном...

ной волной. Так правильно, С. разделяют при взаимодействии... системы и т. н. гравитация. В гравитации С. (рис. 1) взаимодействуют...

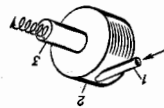


Рис. 1. Схема взаимодействия.

Различные взаимодействия в результате прецессии вихри, связанной с магнитизмом, номером 2, в к-ром газ по-прежнему находится в равновесии...



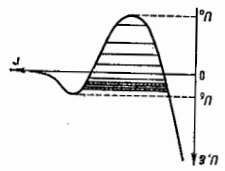
Рис. 2. Схема вихря системы 1 - магнетизм с осевым вихрем 2.

при наложении и отклонении пилларского или турбулентного потока, куда так также впадают течения. Меридианы (миланские) С. разделяют...

Различные колебания на резонансной частоте пластинчатых колебаний на резонансной частоте пластинчатых колебаний на резонансной частоте пластинчатых колебаний...

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (свободные колебания) - колебания колеблющейся системы, совершаемые при отлучении являющегося на себя первого...

СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - свободные колебания системы, состоящие из взаимодействия колеблющихся систем, связанных между собой...

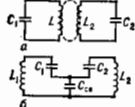


колебания могут иметь различную амплитуду и частоту. В зависимости от условий взаимодействия...

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (свободные колебания) - колебания колеблющейся системы, совершаемые при отлучении являющегося на себя первого...

ло к-рых равно числу парциальных систем. С. к., являющиеся суперпозицией двух или неск. нормальных колебаний с близкими частотами, воспринимаются как *биения*.

СВЯЗАННЫЕ СИСТЕМЫ — колебательные системы с двумя и более степенями свободы, рассматриваемые как совокупность систем с одной степенью свободы каждая (парциальных систем), взаимодействующих между собой. Примеры С. с. — два или неск. колебательных контуров (рис.), у к-рых колебания в одном



Схемы простейших колебательных систем: а — индуктивная связь; б — ёмкостная связь; С — ёмкости; L — индуктивности.

контуре в-за наличия связи вызывают колебания в других. В С. с. происходит переход энергии на одной системе в другую. Наличие связи изменяет характер резонансных явлений в С. с. по сравнению с одиночным контуром. В С. с. *резонанс* наступает всякий раз, когда частота внеш. воздействия совпадает с одной из частот *собственных колебаний* всей системы, отличающихся от парциальных частот отд. контуров. Напр., в С. с., состоящей из двух контуров, резонанс наступает на двух разл. частотах.

СВЯЗИ МЕХАНИЧЕСКИЕ — ограничения, к-рые налагаются на положения и скорости точек механич. системы и выполняются независимо от того, какие заданные силы действуют на систему. Обычно С. м. осуществляются с помощью к.-н. тел. Примеры таких С. м.: поверхность, по к-рой скользит или катится тело; нить, на к-рой подвешен груз; шарниры, соединяющие звенья механизмов, и т. п. Если положения точек механич. системы по отношению к данной системе отсчёта определять их декартовыми координатами x_k, y_k, z_k ($k = 1, 2, \dots, n$, где n — число точек системы), то ограничения, налагаемые С. м., могут быть выражены в виде равенств (или неравенств), связывающих координаты x_k, y_k, z_k , их первые производные по времени $\dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k$ (т. е. скорости точек системы) и время t .

С. м., налагающие ограничения только на положения (координаты) точек системы и выражающиеся ур-ниями вида

$$f(\dots, x_k, y_k, z_k, \dots, t) = 0, \quad (1)$$

наз. *геометрическими*. Если же С. м. налагают ограничения ещё и на скорости точек системы, то они наз. *кинематическими* или *дифференциальными*, а их ур-ния имеют вид:

$$\varphi(\dots, x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k, \dots, t) = 0. \quad (2)$$

Когда ур-ние (2) может быть проинтегрировано по времени, соответствующая кинематич. связь наз. *интегрируемой* или *эквивалентна геом. связи*. Геом. и интегрируемые кинематич. связи носят общее название *голономных* ур-ний С. м. (см. *Голономная система*). Кинематич. неинтегрируемые С. м. наз. *неголономными* (см. *Неголономная система*).

С. м., не изменяющиеся со временем, наз. *стационарными* [ур-ния (1) или (2) для таких С. м. время t явно не содержат]; С. м., изменяющиеся со временем [как в ур-ниях (1) и (2)], наз. *нестационарными*. Наконец, когда ограничения, налагаемые С. м., сохраняются при любом положении системы, эти С. м. наз. *удерживающими* и выражаются ур-ниями вида (1) или (2). Если же С. м. указанными свойствами не обладают и точки системы могут от таких связей *освободиться* (напр., груз, подвешенный на нити), то такие С. м. наз. *неудерживающими* и выражаются неравенствами вида $f(\dots, x_k, y_k, z_k, \dots) \geq 0$.

Методы решения задач механики существенно зависят от характера С. м., наложенных на систему. Эффект действия С. м. можно учитывать введением соответствующих сил, наз. *реакциями связей*; при этом для определения реакций (или для их исключения) к ур-ниям равновесия или движения системы должны присоединиться ур-ния связей вида (1) или (2). С. м., для к-рых сумма элементарных работ всех реакций связей на любом возможном перемещении системы равна нулю, наз. *идеальными* (напр., лишенная трения поверхность или гибкая нить). Для механич. систем с идеальными С. м. можно сразу получить ур-ния равновесия или движения, не содержащие реакций связей, используя *возможных перемещений принцип*, *Д'Аламбера — Лагранжа принцип* или *Лагранжа уравнения механики*.

Лит. см. при ст. *Механика, Динамика*. С. м. Терм. **СВЯЗНОСТЬ** — дифференциальное геометрическое правило, составляющее каждому тензору $T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q}$ типа (p, q) его ковариантную производную $\nabla_k T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q}$ являющуюся тензором типа $(p, q + 1)$. В координатах x^1, \dots, x^n задаётся набором *Кристоффеля символов* Γ_{ij}^k по ф-ле:

$$\nabla_k T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q} = \frac{\partial T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q}}{\partial x^k} + \Gamma_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q} T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q} + \dots + \Gamma_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q} T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q} - \Gamma_{jk}^i T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q} - \dots - \Gamma_{jk}^i T_{j_1, \dots, j_p}^{i_1, \dots, i_q}$$

При замене координат $x^i \rightarrow y^i(x^1, \dots, x^n)$ величины Γ_{ij}^k должны заменяться на

$$\tilde{\Gamma} = \frac{\partial y^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^l}{\partial y^m} \frac{\partial x^s}{\partial y^r} \Gamma_{ij}^k + \frac{\partial^2 x^k}{\partial y^m \partial y^r} \frac{\partial y^i}{\partial x^l}$$

С. определяет параллельный перенос тензоров вдоль кривых: тензор T параллелен вдоль кривой $x^i = x^i(t)$, $i = 1, \dots, n$, если $\dot{x}^k \nabla_k T^i = 0$. Ур-ниями $\dot{x}^k \nabla_k T^i = 0$ определены геодезич. С.

Тензор кручения С. определяется ф-лой $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k - \Gamma_{ij}^k$. С. с нулевым кручением наз. *симметричными*. Кривизна С. определяется *кривизной тензором*

$$R_{jkl}^i = \frac{\partial \Gamma_{jk}^i}{\partial x^l} - \frac{\partial \Gamma_{jl}^i}{\partial x^k} + \Gamma_{jk}^s \Gamma_{sl}^i - \Gamma_{jl}^s \Gamma_{sk}^i$$

Через кривизну и кручение выражаются *коммутаторы ковариантных производных*, напр. для векторов T^i имеем:

$$[\nabla_k, \nabla_l] T^i = \nabla_k (\nabla_l T^i) - \nabla_l (\nabla_k T^i) = R_{jkl}^i T^j + \Gamma_{kl}^j \nabla_j T^i$$

В к-л из доп. в С. задаётся, по определению, условиями $\Gamma_{ij}^k = 0$ в нек-рых координатах; в этом случае координаты наз. *евклидовыми*. В таких координатах ковариантные производные совпадают с частными. Тем самым евклидова С. определяет правила дифференцирования тензоров в любых *криволинейных координатах*. С. является евклидовой (локально), если её кривизна и кручение равны нулю.

В *римановом пространстве* (или *севдоримановом пространстве*) С. однозначно определяется по римановой метрике (*инвариантной метрике*) g_{ij} условиями $\nabla^k g_{ij} = 0$, $\Gamma_{ij}^k = 0$. Параллельный перенос при этом сохраняет длины векторов и углы между ними:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right);$$

тензор кривизны этой С. наз. *тензором кривизны риманова пространства*.

С. и построенные по ней тензоры используются в ур-ниях *общей теории относительности*.

С. в расслоении со структурной группой G — то же, что калибровочное поле. Поля $\psi(x)$, принимающие значения в зарядовом пространстве, играют при этом роль тензорных полей. Если $A_i(x)$ — калибровочное поле, принимающее значение в Ли алгебре $L(G)$ группы G симметричного зарядового пространства (т. е. матричнозначное), то ковариантные производные поля ψ определяются F -лами:

$$\nabla_i \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x^i} - A_i \psi.$$

Осп. их свойство — при локальных зарядовых преобразованиях $\psi(x) \rightarrow g(x)\psi(x)$ [где $g(x)$ принимает значения в группе G] и калибровочных преобразований

$$A_i(x) \rightarrow g(x)A_i(x)g^{-1}(x) + \frac{\partial g(x)}{\partial x^i} g^{-1}(x)$$

производная $\nabla_i \psi$ преобразуется ковариантно: $\nabla_i \psi(x) \rightarrow g(x)\nabla_i \psi(x)$. Это даёт однозначный рецепт введения ковариантных полей $A_i(x)$ и $\psi(x)$: если $L_0(\psi, \partial\psi/\partial x^i)$ — свободный лагранжиан поля ψ , инвариантный относительно зарядовых преобразований, то лагранжиан $L(\psi, \partial\psi/\partial x^i, A_i) = L_0(\psi, \nabla_i \psi)$ описывает калибровочно-инвариантное взаимодействие полей A_i и ψ .

Параллельный перенос полей ψ вдоль кривой $x^i = x^i(t)$ определяется из уравнения $\dot{x}^i \nabla_i \psi = 0$. Кривизна S в расслоении определяется флор:

$$F_{ij} = [\nabla_i, \nabla_j] = \frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j} + [A_i, A_j],$$

где скобки обозначают коммутатор. При калибровочных преобразованиях она меняется по закону:

$$F_{ij}(x) \rightarrow g(x)F_{ij}(x)g^{-1}(x).$$

Если кривизна S равна нулю, то калибровочное поле локально представляется в виде $A_i(x) = (\partial g(x)/\partial x^i)g^{-1}(x)$ и калибровочных преобразований приводится к нулевому. Кривизна S определяет изменение поля $\psi(x)$ при параллельном переносе вдоль контура бесконечно малого параллелограмма со сторонами $\delta x^i, \delta x^j$: $\delta\psi = F_{ij}\delta x^i \delta x^j$. Она удовлетворяет тождеству B и κ и ν : $\nabla_i F_{jk} + \nabla_k F_{ij} - \nabla_j F_{ki} = 0$, где $\nabla_i F_{jk} = \partial F_{jk}/\partial x^i + [A_i, F_{jk}]$. В полной лагранжиан калибровочных теорий, используемых, напр., в теории сильных взаимодействий, кривизна входит в инвариантную комбинацию $-(1/4e^2)\text{Sp}(F_{ij}F^{ij})$ (здесь Sp — след матрицы, e — заряд).

Лит.: Славнов А. А., Оликов Ф. Д., Введение в квантовую теорию калибровочных полей, 2 изд., М., 1988; Дубровин В. А., Новиков С. П., Фомин А. Т., Современная геометрия, 2 изд., М., 1986. Б. А. Дубровин.

СВЯЗЬ ВЕКТОРНАЯ — наглядная модель векторного сложения орбитальных l_i и спиновых s_i моментов в полный момент J квантовой системы (атома, атомного ядра, молекулы), характеризующая взаимодействие электронов в атомах и молекулах и нуклонов в атомных ядрах.

В нулевом приближении энергия атома определяется сферически симметричной частью электростатич. взаимодействия $V_{\text{эс}}$ электронов с ядром и между собой. При этом каждый уровень энергии системы, имеющий конфигурацию $n_1 l_1 s_1 n_2 l_2 s_2 \dots n_i l_i s_i$, оказывается $2i(2l_i + 1)(2s_i + 1) \dots (2l_1 + 1)$ -кратно вырожденным в соответствии с числом возможных проекций орбитального l_i и спинового s_i моментов.

Центральная часть взаимодействия $V_{\text{эс}}$ и спин-орбитальное взаимодействие $V_{\text{со}}$ приводят к расщеплению уровня энергии атома на подуровни, относительное расположение k -рых во мн. случаях можно описать с помощью определённой схемы сложения моментов l_i и s_i т. е. типом S в.

Для двух неэквивалентных электронов с моментами l_1, s_1 и l_2, s_2 возможны след. типы S в.:

$$LS\text{-связь: } l_1 + l_2 = L, s_1 + s_2 = S, L + S = J,$$

$$LK\text{-связь: } l_1 + l_2 = L, l_1 + s_1 = K, K + s_2 = J,$$

$$jK\text{-связь: } l_1 + s_1 = j_1, j_1 + l_2 = K, K + s_2 = J,$$

$$jj\text{-связь: } l_1 + s_1 = j_1, l_2 + s_2 = j_2, j_1 + j_2 = J.$$

При любой схеме S в. векторное сложение всех моментов даёт один и тот же полный момент J системы. Два промежуточных квантовых числа используются для обозначения типа связи и классификации подуровней энергии.

Для алектронной оболочки из эквивалентных электронов (т. е. электронов, состояние k -рых описывается одинаковым набором квантовых чисел) вследствие Паули принципа возможен лишь LS - или jj -тип S в., в k -рых все электроны участвуют симметричным образом, что следует из принципа неразличимости электронов.

Каждый тип S в. характеризует относит. величины разл. типов взаимодействия электронов. В случае LS -связи (наз. ещё нормальной или расщепл.-саундированной связью) электростатич. взаимодействие намного больше спин-орбитального: $V_{\text{эс}} \gg V_{\text{со}}$. Нормальная связь характерна для не очень тяжёлых нейтральных и слабоионизов. атомов, находящихся в не слишком высоковольтных состояниях. В противоположном случае $V_{\text{со}} \gg V_{\text{эс}}$ реализуется jj -связь. Она используется для описания уровней энергии тяжёлых атомов и мезоатомных ионов. Переход от LS - к jj -типу S в. с ростом заряда ядра Z объясняется разной зависимостью $V_{\text{эс}}$ и $V_{\text{со}}$ от Z : электростатич. взаимодействие $V_{\text{эс}} \propto Z^2$, а спин-орбитальное $V_{\text{со}} \propto Z^4$. Поэтому в изоэлектронном ряду с ростом Z происходит непрерывный переход от LS - к jj -связи. Относит. роль взаимодействий $V_{\text{эс}}$ и $V_{\text{со}}$ может быть различной для разных уровней энергии одного и того же атома или иона, поэтому при классификации энергетич. спектра одной и той же конфигурации часто используются разл. типы S в.

Нормальная и jj -связи наз. однородными типами связи, а LK - и jK -связи — неоднородными. В ряде случаев их один из типов «чистой» связи не является точным и приходится использовать промежуточные типы связи. Общее число уровней с данным J одинаково для всех типов связи. (Классификация уровней энергии см. в ст. *Мультиплетность*.)

Лит.: Никитин А. А., Рудяк С. В., Основы теории спектров атомов и ионов, М., 1983. В. П. Шельголь.

СГС СИСТЕМА ЕДИНИЦ — система единиц физ. величин с осн. единицами: сантиметр, грамм, секунда (СГС); принята 1-м Международным конгрессом электроники (Париж, 1881) в качестве системы единиц, охватывающей механику и электродинамику. Для электродинамики первоначально были приняты две СГС с. е.: электромагнитная (СГСМ) и электростатическая (СГСЭ). В основу построения этих систем был положен Кулона закон взаимодействия электрич. зарядов (СГСЭ) и магн. подюсов (СГСМ). Единицы СГСЭ и СГСМ отличаются не только численным значением, но и размерностью, т. к. в соотношения размерностей входит размерность скорости в разных степенях.

В системе единиц СГСМ магн. проницаемость вакуума (магнитная постоянная) $\mu_0 = 1$, а электрич. проницаемость вакуума (электрическая постоянная) $\epsilon_0 = 1/c^2$ сг/см²; единицей магн. потока является максвелл (Мкс, Мх), магн. индукция — гаусс (Гс, Гс), напряжённость магн. поля — эрстед (Э, Ое), магнитодвижущая сила — гильберт (Гб, Гб). Электрич. единицам в этой системе соств. наименований не присвоено.

В системе СГСЭ $\epsilon_0 = 1$, $\mu_0 = 1/c^2$ сг/см². Электрич. единицы СГСЭ соств. наименований не имеют; их размер, как правило, неудобно для измерений и их применяют обычно только в теоретич. работах.

Со 2-й пол. 20 в. наиб. распространение получила т. в. СГС симметричная система единиц (Гаусса система единиц, смешанная система единиц). В ней $\mu_0 = 1$ и $\epsilon_0 = 1$; магн. единицы этой си-

стемы равны единицам СГСМ, а электрические — единицы СГСЭ.

Применение СГС с. е. допускается в науч. исследованиях. Соотношение важнейших единиц системы СГС и соответствующих единиц СИ приведены в табл.

Величина	Система единиц			
	СИ	СГСМ	СГСЭ	СГС симметричная
Сила	1 Н	10^{-3} Д	10^{-8} Д	1 дин= 10^{-5} Н
Работа, энергия	1 Дж	10^{-7} Дж	10^{-8} Дж	1 эрг= 10^{-7} Дж
Динамич. вязкость	1 Па·с	0,1 Па·с	0,1 Па·с	1 П=0,1 Па·с
Кинематич. вязкость	1 м ² /с	10^{-4} м ² /с	10^{-4} м ² /с	1 Ст= 10^{-4} м ² /с
Давление	1 Па	0,1 Па	0,1 Па	1 дин/см ² =0,1 Па
Сила тока	1 А	10 А	(10/с) А	(10/с) А ≈ $\frac{1}{3 \cdot 10^9}$ А
Электрич. заряд	1 Кл	10 Кл	(10/с) Кл	(10/с) Кл ≈ $\frac{1}{3 \cdot 10^9}$ Кл
Электрич. напряжение	1 В	10^{-3} В	10^{-8} В	$1 \approx \frac{1}{3 \cdot 10^9}$ В ≈ 300 В
Электрич. сопротивление	1 Ом	10^{-9} Ом	10^{-8} с ² Ом	10^{-9} с ² Ом ≈ $9 \cdot 10^{11}$ Ом
Противостояние электрич. ёмкости	1 Ф	10^9 Ф	(10 ⁹ /с ²) Ф	(10 ⁹ /с ²) Ф ≈ $\frac{1}{9 \cdot 10^{11}}$ Ф
Напряжённость магн. поля	1 А/м	$10^3/(4\pi)$ А/м	$10^3/4\pi$ А/м	1 Э= $10^3/4\pi$ А/м ≈ $79,6$ А/м
Магн. индукция	1 Тл	10^{-4} Тл	10^{-4} с Тл	1 Гс= 10^{-4} Тл
Магн. поток	1 Вб	10^{-8} Вб	10^{-8} с Вб	1 Макс= 10^{-8} Вб

Лит.: Сеня Л. А., Единицы физических величин и их размерности, 3 изд., М., 1989.

СДВИГ — простейшая деформация тела, вызываемая касат. напряжениями т. С. выражается в искажении углов элементарных параллелепипедов (рис. 1), из к-рых можно считать составленным однородное тело;

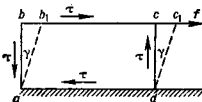


Рис. 1.

сти γ можно считать $\text{tg} \gamma = \gamma$, т. е. что относительный С. равен γ . В пределах упругости для изотропного материала относительный С. связан с законом Гука: $\tau = G\gamma$, где G — модуль С. для данного материала (см. *Модули упругости*). С. всегда сопутствует растяжению, сжатию и изгибу, т. к. во всех этих случаях одновременно с нормальными возникают и касат. напряжения.

Напряжённое состояние, при к-ром 2 гл. напряжения равны по величине и обратны по знаку, наз. чистым С. В этом случае (рис. 2) нормальное напряжение на площадках, образующих с направлением см. углы 45° , равно нулю, а касат. напряжения достигают макс. величин. Т. о., элементарный куб $abcd$ находится в условиях чистого С., причём касат. напряжения, действующие по его граням, равны между собой. Чистый С. имеет место при кручении.

Потенциальная энергия С. для первоначально прямо-угольного параллелепипеда длиной l при площади

основания S и сдвигающей силе F может быть представлена ф-лами: $W = F^2/2SG = \tau^2 S l / 2G$, а уд. потенциальная энергия $w = W/V = \tau^2 / 2G$, где $V = lS$ — объём параллелепипеда.

СДВИГА МОДУЛЬ — см. *Модули упругости*.

СДВИГОВАЯ ВОЛНА — поперечная упругая волна, распространяющаяся в твёрдых телах. Смещения частиц в С. в. перпендикулярны направлению распространения волны, а деформация являются деформациями сдвига. Фазовая скорость С. в. $c_s = \sqrt{\mu/\rho}$, где μ — модуль сдвига материала, ρ — его плотность. Для большинства твёрдых тел значения фазовых скоростей С. в. составляют 1,7—3,5 км/с. В анизотропных твёрдых телах (кристаллах) С. в. могут распространяться только в определённых направлениях, причём их фазовая скорость зависит от направления распространения. При произвольном направлении распространения движение в волне усложняется и она переходит в квазипоперечную волну в кристалле. В ряде кристаллов объёмная С. в. может преобразовываться в слабеволновую поперечную акустическую волну вследствие наличия пьезоэффекта. Объёмная С. в. в металле может стать поперечной под действием сильного постоянного магн. поля, направленного вдоль свободной поверхности металла и под углом к направлению распространения волны. На гиперзвуковых частотах $\sim 10^9$ Гц и выше С. в. могут существовать и в жидкости из-за наличия у неё в этом частотном диапазоне модуля сдвига.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория упругости, 4 изд., М., 1987, гл. 3, § 22, 23; Колосов И. Г., Волны вращивания в твёрдых телах, пер. с англ., М., 1955, кн. 1, гл. 2, § 1—4; Викторов И. А., Звуковые поверхностные волны в твёрдых телах, М., 1981.

СЕГНЕТОПОЛУПРОВОДНИКИ — кристаллы, обладающие одновременно сегнетоэлектрич. и полупроводниковыми свойствами. В С. при определённых темп-рах и в отсутствие внеш. электрич. поля существует спонтанная электрич. поляризация (электрич. дипольный момент P), к-рая может существенным образом изменяться под влиянием внеш. воздействий (внеш. электрич. поле, давление, темп-ра). Спонтанная поляризация возникает при определённой темп-ре T_K (точка Кюри), при к-рой происходит фазовый переход из параэлектрич. неполярной фазы в сегнетоэлектрич. полярную фазу (см. *Сегнетоэлектрики*).

Сегнетоэлектриками являются полупроводники группы IV^2V^2 , обладающие малой шириной запрещённой зоны $E_g \approx 0,1$ —0,3 эВ. К ним относятся GeTe, SnTe, потенциальный С. PbTe ($T_K \approx 0$ К, см. ниже) и твёрдые растворы на их основе (см. *Полупроводниковые материалы*). Электропроводность этих кристаллов при комнатной темп-ре ($T = 300$ К) составляет $\sigma \approx 10^4$ — 10^5 Ом⁻¹.см⁻¹ при колдовской подвижности носителей заряда $\mu = 5 \cdot 10^4$ — $5 \cdot 10^5$ см²/В·с. Темп-ра Кюри С. IV^2V^2 зависит от концентрации свободных носителей заряда. В кристаллах SnTe, к-рые из-за высокой плотности вакансий Sn имеют дырочную проводимость с высокой концентрацией дырок, T_K понижается вплоть до 0 К при увеличении концентрации дырок до $1,3 \cdot 10^{21}$ см⁻³. В С. с высокой проводимостью экранирование спонтанной поляризации свободными носителями не позволяет проводить её прямым измерениями.

С. группы IV^2V^2 имеют большую ширину запрещённой зоны ($E_g \approx 2$ эВ). При $\mu \sim 10$ см²/В·с они характеризуются малой проводимостью $\sigma \leq 10^{-8}$ Ом⁻¹.см⁻¹ и обладают заметной фотопроводимостью.

Высокоомными полупроводниками с хорошей проводимостью являются сегнетоэлектрики со структурной пероскиты ($E_g \approx 3$ эВ). Так, BaTiO₃ с примесью редкоземельных ионов может иметь проводимость до 10^{-1} Ом⁻¹.см⁻¹ при $\mu \leq 1$ см²/В·с. в то время как при отсутствии примесей $\sigma \leq 10^{-10}$ Ом⁻¹.см⁻¹. Относ.

тельно высокой проводимостью, связанной с вакансиями Pb, обладают кристаллы $PbTiO_3$. Кристалл $SrTiO_3$ (как и $PbTe$) рассматривается как потенциальный (виртуальный) С., т. е. при снижении T вплоть до 0 К этот кристалл приближается к фазовому переходу в сегнетоэлектрич. состоянии, но переход не успевает произойти при реальных темп-рах. Для чистых кристаллов $\sigma \lesssim 10^{-10}$ Ом $^{-1}$.см $^{-1}$. Легиров. кристаллы имеют проводимость до 1 Ом $^{-1}$.см $^{-1}$ при $\mu \approx 5$ см 2 /В.с. Кристаллы $SrTiO_3$ с концентрацией носителей $\sim 10^{19}$ — 10^{20} см $^{-3}$ становятся сверхпроводящими при $T = 0,3$ — $0,5$ К (см. *Сверхпроводники*).

Сегнетоэлектрик $LiNbO_3$ с широкой запрещенной зоной имеет проводимость $\sim 10^{-18}$ Ом $^{-1}$.см $^{-1}$, т. е. является типичным изолятором. Однако при сильном легировании (напр., Fe) σ может достигать 10^{-7} Ом $^{-1}$.см $^{-1}$ при $\mu \approx 0,5$ см 2 /В.с. Легиров. кристаллы обладают заметной фотопроводимостью. Некоторые характеристики С. приведены в табл. К С. можно отне-

Некоторые характеристики сегнеотопроводников

Кристалл	T_c , К	Группа симметрии	Поляризация P_r , мкКл/см 2	d_{33} , эВ
GeTe	870	$m\bar{3}m \rightarrow 3m$	—	0,1—0,2
SrTe	≤ 100	\rightarrow	—	0,2—0,3
SrS	295	$m\bar{3}m \rightarrow m\bar{2}$	25	—
BaTiO $_3$	408	$m\bar{3}m \rightarrow 4mm$	28	2,2
PbTiO $_3$	763	\rightarrow	57	3
SrTiO $_3$	< 0	$m\bar{3}m$	6	3,2
LiNbO $_3$	1483	$\bar{3}m \rightarrow 3m$	70	3,7

сти также кристаллы Ag_3AsS_3 , $Sn_2P_2S_6$, $TlGaSe_2$. Для всех С. связь электронной подсистемы с сегнетоэлектрич. свойствами приводит к небольшим изменениям в точке фазового перехода величины σ , μ , d_{33} .

Фотоэлектрические свойства. Взаимосвязь сегнетоэлектрич. и полупроводниковых свойств приводит к ряду фотоэлектрич. эффектов. Так, при освещении С. наблюдаются сдвиг T_c ($BaTiO_3$, SrS) до 1% от величины T_c . При этом наблюдаются и изменения температурной зависимости диэлектрич. проницаемости в области фазового перехода (фотогигиестрезионный эффект). Поскольку свободные носители в С. экранируют спонтанную поляризацию и оказывают тем самым сильное влияние на доменную структуру, то генерация свободных носителей при освещении С. может приводить к изменению его доменной структуры (фотодомениный эффект).

При однородном освещении в С. возникает стационарный электрич. ток (см. *Фототермический эффект*). Для света с линейной поляризацией ток в кристалле i_i пропорц. интенсивности света I :

$$i_i = \chi_{ik} h_k e_k I,$$

где e_k , h_k — компоненты единичного вектора электрич. поля световой волны. Тензор χ_{ik} отличен от 0 во всех кристаллах без центра инверсии (см. *Симметрия кристаллов*), но, как правило, особенно большую величину он имеет в сегнетоэлектриках. В освещенном С. возникает фотозд., к-рая достигает больших значений. Так, в кристаллах $LiNbO_3$ она соответствует электрич. поля $E \sim 10^4$ — 10^5 В/см.

При локальном освещении С. фотоголовообразование (или) диффузия приводит к переносу возбужденных носителей на периферию светового пучка, где происходит захват носителями ловушками. В результате создается объемный заряд, поле к-рого за счёт электролитич. эффекта приводит к изменению показателей преломления кристалла (фотоэлектрич. эффект).

Сегнетокерамика. В полупроводниковых керамиках (на основе легированного $BaTiO_3$ и др.) взаимное влияние сегнетоэлектрич. и полупроводниковых свойств проявляется в положении температурного коэф. сопротив-

ления (ПТКС). Сопротивление керамики при изменении T резко уменьшается (до 6 порядков) в узкой области T при фазовом переходе в сегнетоэлектрич. фазу. Объяснение основано на представлении о *Шоттки барьерах* на границах зёрен с относительно высокой проводимостью, к-рые разделены изолирующим *запорным слоем*. В области фазового перехода резко возрастает диэлектрич. проницаемость, что приводит к уменьшению высоты барьера и соответственно к экспоненциальному уменьшению сопротивления образца.

В керамике, состоящей из зёрен с полупроводниковой проводимостью и тонких изолирующих слоёв, наблюдается увеличение эфф. диэлектрич. проницаемости ϵ_{eff} на низких частотах. Кроме того, ϵ_{eff} изменяется при приложении слабых электрич. полей E , что связано с зависимостью от поля E толщин обедненного слоя.

Применение. С. обладающие фоторефрактивным эффектом, используются для записи и обработки оптич. сигналов. Сегнетокерамика с эффектом ПТКС применяется для создания приборов в системах теплового контроля и в измерит. технике. Полупроводниковая сегнетокерамика с тонкими межзёрненными прослойками используется в конденсаторах большой ёмкости. Высокоомные С. применяются в гибридных структурах, где возможно управление проводимостью *полевое транзистора* в канале истока — стока путём переключения спонтанной поляризации в сегнетоэлектрич. затворе. Возможно использование переключения сегнетоэлектрич. доменов в плёнках для создания энергонезависимых устройств памяти с высокой ёмкостью и высоким быстродействием (технология таких устройств совместима с кремниевой технологией).

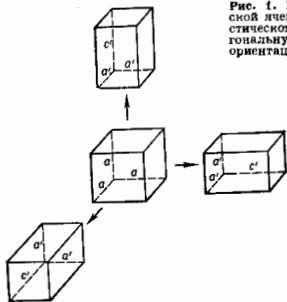
Лит.: Фридкин В. М., Сегнетоэлектрики — полупроводники, М., 1976; его же, Фотоэлектрики, М., 1978; Давис М., Гласс А., Сегнетоэлектрики и родственные им материалы, пер. с англ., М., 1981; Барфут Д., Тейлор Д., Первые диэлектрики и их применения, пер. с англ., М., 1981; В. В. Леманов.

СЕГНЕТОЭЛАСТИКИ (ферроэластики) — кристаллич. вещества, в к-рых при понижении темп-ры возникает спонтанная деформация кристаллич. решётки относительно исходной в отсутствие внеш. механич. напряжений. Термин «С.» ввёл К. Айдау (K. Aizu) 1969. Спонтанная деформация является результатом *структурного фазового перехода* из более симметричной (параэластич.) в менее симметричную (сегнетоэластич.) фазу. Напр., кубич. сингония переходит в тетрагональную, гексагональную или тетрагональную — в ромбическую или моноклиную, ромбическая — в моноклиную (см. *Сингония*).

При сегнетоэластич. переходе кристалл без разрыва своей сплошности теряет ориент. однородность и разбивается на сегнетоэластич. домены, каждый из к-рых принадлежит к одному из нескольких (двух, трёх и т.д.) вариантов изометрич. состояний, отличающихся ориентацией кристаллич. решётки (рис. 1, 2). Возникновение сегнетоэластич. (ориент.) доменов можно рассматривать как частный случай механизма *двойникования*, причём элементами двойникования служат углубления при переходе элементы *говоротной* (точечной) симметрии (см. *Симметрия кристаллов*). В прозрачных С. доменную структуру можно наблюдать с помощью оптич. поляризац. микроскопа благодаря разориентации оптич. индидатрис или разл. двойному лучепреломлению доменов. Наличие ориент. доменов — характерный признак сегнетоэластич. фазы.

Домены могут «переключаться» из одного ориент. состояния в другое под действием механич. напряжений определённой величины и направления. Процесс переключения может происходить, напр., путём рождения тонких клявновидных или линеобразных доменов с последующим их ростом и движением регулярных плоских или энгазообразных доменных границ или путём перемещения одной доменной границы.

Рис. 1. Искажение кубической ячейки при сегнетоэластическом переходе в тетрагональную сигнонию (три ориентационных состояния).



В отличие от линейно упругих материалов или от веществ со слабой упругой нелинейностью, зависимость макроскопической деформации S от приложенного механического напряжения линейна лишь значительно выше

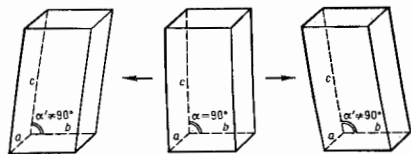
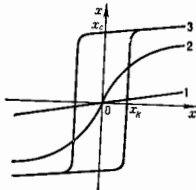


Рис. 2. Искажение ромбической ячейки при переходе в моноклинную сигнонию (два ориентационных состояния).

температуры перехода T_N и приобретает существенно нелинейный характер в параэластической фазе вблизи T_N , переходя в петлю гистерезиса (см. *Гистерезис упругий*) в сегнетоэластической фазе (рис. 3). По петле гистерезиса можно определить величину спонтанной деформации

Рис. 3. Зависимость деформации x от напряжения X при $T > T_N$ (1); вблизи T_N (2) и при $T < T_N$ (3).



x (для S характерны большие величины $x \sim 10^{-3} - 10^{-1}$) и т. в. коэффициентного напряжения X_N при k -ром происходит переключение доменов. Значения X_N варьируются в пределах от $10^8 - 10^9$ Па для «эластомягких» S , до 10^8 Па для «эластожёстных». S являются упругими аналогами сегнетоэлектриков и ферромагнетиков (см. *Ферроэластики*).

Анализ сегнетоэластич. фазовых переходов и аномалий упругих свойств S базируется на феноменологич. теории фазовых переходов Ландау. Исходным пунктом его является построение термодинамич. потенциала Φ , зависящего от параметра порядка η , являющегося внутренней макроскопич. переменной, характеризующей изменение пространственной симметрии кристалла (точечной и трансляционной) при фазовом переходе.

Параметр порядка $\eta = 0$ при $T > T_N$ и $\eta \neq 0$ при $T < T_N$. Вблизи T_N параметр η мал и термодинамич. потенциал может быть разложен по степеням η :

$$\Phi = \Phi_0 + r\eta^2 + u\eta^4 + U\eta^6 + \dots$$

Здесь Φ_0 — не зависящий от η потенциал в исходной фазе, r — параметр, зависящий от температуры T . Равновесное значение параметра порядка определяется из условия $\partial\Phi/\partial\eta = 0$ и $\partial^2\Phi/\partial\eta^2 > 0$. Потенциал Φ содержит также члены, характеризующие связь η и x (в общем случае η и x — многокомпонентные величины). Характер связи зависит от изменения симметрии — не только точечной, но и трансляционной. Если параметр порядка η и спонтанная деформация x преобразуются операциями симметрии одинаково, то S наз. собственными. При собств. сегнетоэластич. переходе изменяется только точечная симметрия кристалла, но не меняется трансляционная. При несобств. сегнетоэластич. переходе меняется также и трансляц. симметрия, а объём элементарной ячейки увеличивается (умножается). При этом помимо ориентационных возникают также трансляционные (антифазные) домены.

Термодинамич. анализ потенциала Φ позволяет описать аномалии разл. свойств в окрестности температуры T_N — скачок теплоёмкости C_p , температурные зависимости деформации x (коэф. теплового расширения α), поляризации P (если сегнетоэластич. фаза обладает сегнетоэлектрич. свойствами), упругих жёсткостей s или податливостей s , диэлектрич. проницаемостей ϵ и т. д. При этом вид аномалий для собственных и несобственных S различен (рис. 4). При фазовом переходе

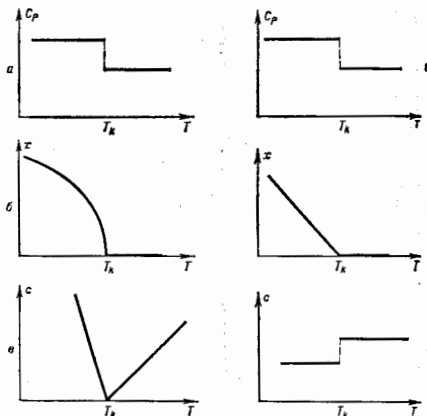


Рис. 4. Температурные зависимости теплоёмкости C_p , спонтанной деформации x и упругой жёсткости s при собственном (а, б, в) и несобственном (г, д, е) сегнетоэластическом переходе.

2-го рода в собств. S при $T < T_N$ сдвиговая спонтанная деформация изменяется с T по закону $x \sim \eta \sim (T_N - T)^{1/2}$, а в несобственном — как $x \sim \eta^2 \sim (T_N - T)$. Соответствующая компонента жёсткости в собств. S ведёт себя как $(T - T_N)$ выше и ниже T_N , т. е. при $T \rightarrow T_N$ в обеих фазах наблюдается уменьшение жёсткости и падение скорости звука. В несобств. S этого не происходит и при T_N наблюдается скачок и(или) изменение температурного коэф. жёсткости.

В отличие от феноменологич. теории, микроскопич. теория конкретизирует механизм фазового перехода и рассматривает взаимодействие частей, составляющих кристаллич. решётку, с учётом её трансляц. симметрии. Как и в случае сегнетоэлектриков различают С-типа смещения и типа порядок — беспорядок.

С — многочисл. класс кристаллов, претерпевающих структурные фазовые переходы. Кристаллохим. классификация С. группирует их по типу пространственной укладки «ластоаэтичных» высокосимметричных (октаэдрических или тетраэдрических) анионных или катионных комплексов, повороты или деформация к-рых могут приводить к понижению симметрии кристалла. Структурная классификация С. обычно указывает структурный тип «родоначальника» семейства изоморфных кристаллов (интернациональное назв. минерала). Семейства С. образуют пальмитеры $[Pb_2(PO_4)_2]$, ферроситы (BIVO), тейлориты (K_2CrO_4) , тридимиты $(CaSiO_3)$, лангбейниты $(K_2Cd_2SO_4)$, двойные тригональные молибдаты и вольфраматы $[KFe(MoO_4)_2]$, редкоземельные пентафосфаты (LaF_3O_4) , ферроситы (Ba_2TiGeO_{12}) , дителлуриды $(SrTe_2O_8)$, семейство $K_2Zn(MoO_4)_2$, С. с водородными связями H_3BO_3 , $KH_2(SeO_3)_2$, перовскиты $(KMnF_3)$ и альзинолиты $(Ca_2NaNdCl_4)$, каломель (Hg_2Cl_2) .

Свойства С., и особенно С-сегнетоэлектриков, обуславливают их применение. Напр., на основе редкоземельных молибдатов, в частности молибдата гадолиния, разработаны акустозащитные устройства, в к-рых используется взаимодействие распространяющейся акустич. волны с одиночной доменной стенкой или с регулярированной полидоменной структурой. Они управляют элетрич. полем или механ. напряжением. С. обладают высокой акустоупит. эффективностью (см. *Акустоэлектрика*). Сегнетоэластич. фазовые переходы испытывают многие кристаллы — высокотемпературные сверхпроводники, а также ионные суперпроводники.

Лит.: Aizu K., Possible species of ferroelastic crystals and of simultaneously ferroelectric and ferroelastic crystals, *J. Phys. Soc. Japan*, 1969, т. 27, с. 387; Ягловцев В. Дворák V., Petzelt J., Symmetry classification and properties of equi-translation structural phase transitions, «Czech. J. Phys.», 1975, т. B25, p. 1362; Фазовые переходы в кристаллах различных составов А. В. Кристаллохимия, структурные и магнитные превращения, Новосибир., 1981; Ивюмов Ю. А., Сыромятников В. П., Фазовые переходы и симметрия кристаллов, М., 1984; Материалы I—IV Всесоюзных семинаров по физике сегнетоэлектриков, «Изв. АН СССР. Сер. физ.», 1979, т. 43, № 8, с. 1553; 1983, т. 47, № 3, с. 417; 1986, т. 50, № 2, с. 310; 1989, т. 53, № 7, с. 1233. Н. Р. Иванков.

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ — кристаллич. диэлектрики (полупроводники), обладающие в определённом диапазоне темп-р спонтанной поляризации, к-рая существенно изменяется под влиянием внеш. воздействий. Структуру С. можно представить как результат фазового перехода кристалла с искажением структуры (понижением симметрии) за неполярной структуры (параэлектрич. фазы) в полярную (сегнетоэлектрич. фазу). В большинстве случаев это искажение структуры такое же, как и при воздействии элетрич. поля на кристалл в неполярной (параэлектрич.) фазе. Такие С. наз. собственными, а искажение неполярной структуры связано с появлением спонтанной элетрич. поляризации. В ряде С. поляризация возникает как вторичный эффект, сопровождающий нерестройку структуры, к-рая не связана непосредственно с поляризацией и не может быть вызвана элетрич. полем. Такие С. наз. несобственными.

Как правило, наблюдается фазовый переход непосредственно между сегнето- и параэлектрической (более симметричной) фазами. Однако есть кристаллы, в к-рых между этими фазами осуществляется промежуточная фаза с особыми свойствами — т. н. несоответствующая фаза (см. ниже).

Особенностью всех С. является относит. близость структур пара- и сегнетоэлектрич. фаз. Изменения ср. положений ионов при возникновении спонтанной по-

ляризации обычно гораздо меньше, чем межпериодные расстояния. Поэтому спонтанная поляризация С. легко изменяется под влиянием внеш. воздействий — элетрич. полей, упругих напряжений, изменений темп-ры и др. С этим связаны весьма высокие (по сравнению с обычными диэлектриками) значения диэлектрич. проницаемости, пьезоэлектрических (см. *Пьезоэлектрики*) и пирозаэлектрических (см. *Пирозаэлектрики*) постоянных.

Сегнетоэлектрич. свойства были впервые обнаружены у кристаллов сегнетовой соли $KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$ (1921), а затем у дигидрофосфата калия KH_2PO_4 (1935). Интенсивные исследования С. начались в 1945, когда были обнаружены сегнетоэлектрич. свойства керамики $BaTiO_3$ — родоначальника обширного семейства С. кислородно-октаэдрич. типа. В 60-х гг. начались исследования несобст. С., в сер. 70-х гг. — С. с несоответствующей фазой. К 1990 известно неск. сотен С.; характеристики нек-рых из них приведены в табл.

Характеристики некоторых сегнетоэлектриков (С — собственный, Н — несоответствующий, НС — несоответствующий фазой)

Вещество	Формула	Тип	$T_K, ^\circ C$	Спонтанная поляризация на единицу смещения $(T \ll T_K)$, мКл/см ²	Группа симметрии в неполярной фазе	Группа симметрии в полярной фазе
Титанат бария . . .	$BaTiO_3$	С	133	25	m3m	4mm
Сегнетова соль . . .	$KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$	С	-18,24	0,25	222	2
Триглицин-сульфат	$(CH_3NH_3CO \cdot OH) \cdot H_2SO_4$	С	49	2,8	2/m	2
Дигидрофосфат калия	KH_2PO_4	С	-150	5,1	$\bar{4}2m$	mm2
Молибдат гадолиния	$Gd_4(MoO_4)_8$	Н	159	0,18	$\bar{4}2m$	mm2
Фторбисфосфат аммония . . .	$(NH_4)_2BeF_6$	НС	-98	0,15	mmm	mm2

Феноменологическая теория. Фазовые переходы в С. — переходы 2-го рода или 1-го рода, близкие ко второму. Для описания свойств С. в области фазовых переходов обычно используется теория Ландау, конкретизированная В. Л. Гинзбургом применительно к С. Теория исходит из факта существования фазового перехода при понижении темп-ры до $T = T_K$; характерной особенностью перехода является исчезновение нек-рых элементов симметрии, связанное со смещением из симметричных положений определённых типов атомов в кристаллич. решётке. Совокупность этих смещений связана с параметром порядка Q , к-рый равен 0 при $T > T_K$. В собств. С. параметром порядка являются одна (одноосный С.) либо 2, 3 (многоосный С.) компоненты вектора поляризации P . В одноосном собств. С. $P = ap$, где a — пост. коэффициент. В несобств. С. Q является многокомпонентной величиной, связанной со смещением атомов при переходе в несимметричную фазу.

В феноменологич. теории термодинамич. потенциал F кристалла рассматривается как ф-ция компонент параметра порядка. Для собственного одноосного С., свободного от механ. напряжений, в элетрич. поле E имеем:

$$\Phi = \Phi_0(T) + \frac{1}{2} \alpha(T - T_K) \mathcal{P}^2 + \frac{1}{4} \beta \mathcal{P}^4 - E_2 \mathcal{P}_z. \quad (1)$$

Здесь E_2, \mathcal{P}_z — компоненты векторов поляризации \mathcal{P} и элетрич. поля E вдоль полярной оси кристалла z . Для несоответствующего одноосного С. (один из случаев):

$$\Phi = \Phi_0 + \frac{1}{2} \alpha (T - T_N) \left(\eta_1^2 + \eta_2^2 \right) + \frac{1}{4} \beta_1 \left(\eta_1^4 + \eta_2^4 \right) + \frac{1}{2} \beta_2 \eta_1^2 \eta_2^2 - a \eta_1 \eta_2 \mathcal{P}_2 - E_2 \mathcal{P}_2. \quad (2)$$

Здесь η_1, η_2 — компоненты параметра порядка; $a, \alpha, \beta, \beta_1, \beta_2$ — постоянные коэффициенты.

Равновесные свойства собственных и несобственных С. могут быть получены путём определения равновесных значений $\eta_1, \eta_2, \mathcal{P}_2$ из условия минимума термодинамич. потенциала Φ по отношению к этим величинам. Анализ приводит к зависимостям от темп-ры T компонент параметра порядка η , спонтанной поляри-

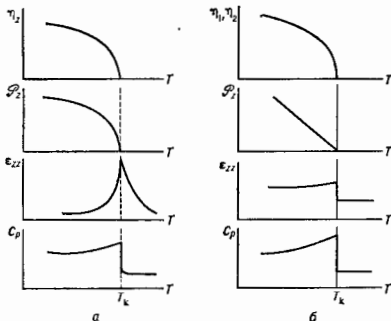


Рис. 1. Температурные зависимости компонент параметра порядка η , спонтанной поляризации \mathcal{P}_2 , диэлектрической проницаемости ϵ_{zz} вдоль полярного направления z , теплоёмкости C_p для собственных (а) и несобственных (б) сегнетоэлектриков.

зации \mathcal{P}_2 , диэлектрич. проницаемости ϵ , теплоёмкости C_p (рис. 1). Так, спонтанная поляризация для собственных С.:

$$\mathcal{P}_2 \approx \eta_2 = \pm \left[-\frac{\alpha(T - T_N)}{\beta} \right]^{1/2}, \quad (3)$$

для несобственных С.:

$$\mathcal{P}_2 \approx \eta_1 \eta_2; \quad (4)$$

$$\eta_1^2 = \eta_2^2 = -\frac{\alpha(T - T_N)}{2\beta_1 + \beta_2}. \quad (5)$$

«Вторичность» спонтанной поляризации в несобств. С. следует из того, что $\mathcal{P}_2 \approx \eta_1 \eta_2$. Диэлектрич. проницаемость в собств. С. при фазовом переходе 2-го рода следует закону Кюри — Вейса: $\epsilon_{zz} = C/(T - T_N)$, где C — постоянная. В несобств. С. ϵ испытывает скачок при $T = T_N$. В обоих случаях теплоёмкость C_p меняется в точке фазового перехода скачком.

Поведение С. в области $T \sim T_N$, следующее из теории Ландау, экспериментально (в основном) подтверждается; имеющиеся расхождения связываются с дефектами кристаллич. структуры и флуктуат. эффектами. С позиций совр. теории фазовых переходов 2-го рода, теория Ландау не полностью учитывает нарастание флуктуаций параметра порядка η при $T \rightarrow T_N$. Поэтому она неверна в непосредств. близости к T_N . В результате зависимости характеристик кристалла от T оказываются вблизи T_N неаналитическими. Область, где отклонения от предсказаний теории Ландау велики, в большинстве случаев узка, но тем не менее следует ожидать вблизи T_N , напр., отклонений от закона Кюри — Вейса (см. Критические показатели).

Из ур-ний (3) — (5) и рис. 1 следует, что в полярной фазе (при $T < T_N$) равновесные значения спонтанной поляризации \mathcal{P}_2 отвечают минимуму термодинамич. потенциала Φ , могут быть положительными ($\epsilon \rightarrow +$) и отрицательными ($\epsilon \rightarrow -$). Это означает, что в полярной фазе есть неск. направлений для вектора P : для одноосных С. — 2, для трёхосных С. — 6 (по два вдоль каждой из эквивалентных кристаллографич. осей).

Доменная структура. Из сказанного следует, что существует неск. энергетически эквивалентных вариантов структуры полярной фазы (к-рые могут быть переведены одна в другую теми преобразованиями симметрии, к-рые исчезают при фазовом переходе). Это объясняет возможность разбегания С. на домены — области с разл. направлениями P . В несобств. С. возможны, кроме того, домены с одним направлением P , но различающиеся др. структурными характеристиками, т. е. знаком η (т. я. антифаза и ее домены). Характер равновесной доменной структуры определяется требованием минимума полной энергии кристалла. В полярной фазе идеального С. при полной компенсации однородных по объёму электр. и упругих полей (т. е. в электрически замкороченном и механически свободном образце) доменная структура энергетически невыгодна, т. к. образование границы между доменами (домены и о й с т е н и ю) увеличивает энергию кристалла (поверхностная энергия доменной стенки положительна). Однако обычно С. разбиты на домены.

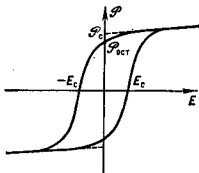
В незакороченных образцах разбегание на домены энергетически выгодно, т. к. возрастание энергии доменных стенок компенсируется уменьшением энергии электростатич. взаимодействия между разл. частями кристалла. Ввиду дальнегодействующего характера электростатич. поля его влияние в данной точке определяется распределением поляризации во всём объёме образца, его формой и размерами, условиями на границах. Поэтому расчёт равновесной доменной структуры в С., даже для образцов простейших форм, представляет собой сложную задачу, пока окончательно не решённую. Сложен и ожидаемый характер доменной структуры, согласно теории, она должна изменяться («ветвиться») вблизи поверхности кристалла.

Однако доменная структура, отвечающая предсказаням теории для идеального С., практически никогда не наблюдается. При образовании доменной структуры важную роль играет предстория образца, напр. условия прохождения через точку Кюри T_N в неравновесных условиях при первом охлаждении кристалла после его выращивания при пом. темп-рах (см. Гистерезис сегнетоэлектрических), а также дефекты кристаллич. структуры. Кроме того, во мнгох С. на характер доменной структуры сильное влияние оказывает экранирование электрич. поля за счёт нераспределения свободных носителей заряда и перераспределения локальных центров (см. Сегнетополиупорядочки).

Влияние внешнего электрического поля на доменную структуру. В С. доменные стенки могут мешаться под действием электр. поля, причём объём доменов, поляризованных по полю, увеличивается за счёт доменов, поляризованных против поля. Возможно также и зарождение новых доменов, поляризация в к-рых ориентирована вдоль E . В реальных кристаллах доменные стенки обычно закреплены на дефектах и неоднородностях, т. е., для того чтобы перейти из одного положения в другое, доменной стенке нужно преодолеть энергетич. барьеры. В сильных электр. полях эти барьеры сглаживаются и стенка может перемещаться по образцу относительно быстро. Возможно и перемещение стенок в слабых полях за счёт термоактивн. преодоления барьера, это перемещение может быть очень медленным. Энергетич. барьеры для перемещения стенок существуют в бездефектных кристаллах благодаря дискретности атомной структуры, аналогично т. я. барьеру Пайерлса для перемещения дислокаций.

Перестройка доменной структуры S под действием поля E определяет характер зависимости $\mathcal{P}(E)$ (рис. 2), имеющей вид петли гистерезиса (в переменном электрич. поле параметры петли существенно зависят от частоты изменения поля). В сильном поле кристалл стано-

Рис. 2. Зависимость поляризации сегнетоэлектриков от электрического поля в полярной фазе: E_c — коэрцитивное поле, $\mathcal{P}_{ост}$ — остаточная поляризация, \mathcal{P}_0 — спонтанная поляризация.



вится однодоменным, при последующем уменьшении поля до 0 поляризация остается отличной от 0 ($\mathcal{P}_{ост}$) и обращается в 0 только при приложении достаточно большого поля противоположного знака (коэрцитивное поле E_c). Величина спонтанной поляризации \mathcal{P}_0 может быть определена по петле гистерезиса линейной экстраполяцией зависимости $\mathcal{P}(E)$ к значению $E = 0$. Характерно, что хотя для бездефектных кристаллов E_c должно обращаться в 0 (абсолютно «свободное» движение доменных стенок), практически оно остается конечным даже для весьма больших периодов изменения поля.

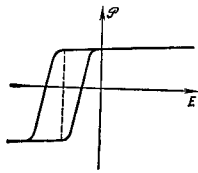
Изменение поляризации кристалла под действием электрич. поля, связанное со смещением доменных стенок, обуславливает большую величину «доменного вклада» в величину диэлектрич. проницаемости ϵ многодоменного $S. T. o.$, в $S.$ величина ϵ зависит от напряженности поля. Все монодоменные $S.$ в полярной фазе — пьезоэлектрики, причём пьезоэлектрич. константы, связывающие деформацию кристалла с электрич. полем, аномально велики из-за больших ϵ (см. *Пьезоэлектрические материалы*). Пироэлектрич. постоянные $S.$ также велики благодаря сильной зависимости \mathcal{P} от T вблизи T_K .

Роль дефектов. Наличие в кристалле дефектов существенно влияет не только на динамику доменных стенок и процессы переориентации, но и на температурные зависимости разл. физ. величин вблизи T_K . Это вызывает расхождение эксперим. данных с предсказаниями теории Ландау. Особенно сильным является влияние т. н. дефектов поля («случайное поле» в собств. $S.$ Это дефекты, обладающие дипольным моментом в неполярной фазе. Если ввести такие дефекты так, чтобы направления их дипольных моментов были одинаковыми (напр., при легировании триглицерсульфата $L-\alpha$ -алянином), то даже при $E = 0$ кристалл становится полярным во всём интервале темп-р.

Приближённо влияние таких дефектов на свойства кристалла можно описать как наличие нек-рого внутреннего «смещающего поля». $S.$ с дефектами, образующими «смещающее поле», важны для приложений, поскольку они устойчиво монодоменны и обладают поэтому стабильными характеристиками (напр., пиро- и пьезоэфф.). Внутреннее «смещающее поле» (как и внешнее) приводит к сглаживанию аномалий фаз. параметров в области $T \sim T_K$ («размытие» фазового перехода), поскольку индуцирует электрич. поляризация и в неполярной фазе. При наличии «смещающего поля» вид зависимости $\mathcal{P}(E)$ изменяется (рис. 3). Величина этого поля может быть определена по смещению петли гистерезиса вдоль оси E . При наличии в кристалле хаотически распределённых и хаотически ориентированных дипольных дефектов «смещающее поле» не возникает; для этого случая характерно рамытие скачков и аномалий термодинамич. величин в области фазового перехода.

Экспериментально даже в наиб. совершенных кристаллах собств. $S.$ наблюдается «сглаживание» аномалии ϵ вблизи T_K (рис. 1), величина ϵ в точке перехода 2-го рода может служить мерой совершенства кристалла, поскольку в идеальном кристалле $\epsilon \rightarrow \infty$ при $T \rightarrow T_K$.

Рис. 3. Вид петли гистерезиса сегнетоэлектриков при наличии внутреннего смещающего поля.



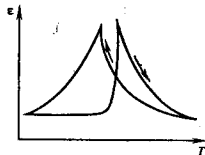
В нек-рых *твёрдых растворах*, напр. $Ba(Tl, Zr)O_2$, наблюдаются «размытые» сегнетоэлектрич. переходы, когда в температурной зависимости ϵ есть широкий максимум. Его положение зависит от частоты переменного поля E , смещаясь в область низких темп-р при повыжении частоты.

Сегнетоэлектрики — несоизмерной фазой. В нек-рых $S.$ исчезновение спонтанной поляризации при нагревании объясняется изменением знака поверхностной энергии доменной стенки. В результате в кристалле спонтанно возникают др. доменные стенки, понижающие энергию системы. Параметры возникающей доменной структуры (в частности, размеры доменов) определяются взаимодействием стенок и являются характеристиками вещества (а не образца, как в случае обычных $S.$). Образующаяся многодоменная фаза из-за несоизмерности, поскольку период «решётки» доменных стенок сильно зависит от веш. условий и не связан с периодом «основной» кристаллич. решётки (см. *Несоизмерная структура*).

Переходы из несоизмерной в полярную соразмерную фазу при понижении темп-р могут быть скачкообразными и непрерывными. В последнем случае в несоизмерной фазе вблизи точки перехода $T - T_K$ расстояние между стенками велико и обращается в бесконечность при $T \rightarrow T_K$. Диэлектрич. проницаемость несоизмерной фазы, состоящей из таких доменов, непрерывно возрастает при $T \rightarrow T_K$, поскольку чем больше удаляются друг от друга доменные стенки, тем легче они смещаются под действием электрич. поля. При подходе к T_K со стороны соразмерной фазы рост ϵ не наблюдается.

Это верно только для состояния термодинамич. равновесия. Поскольку процесс установления равновесия включает рождение или исчезновение доменных стенок, а также изменение расстояния между ними, он занимает, как правило, длительное время, к-рое сильно увеличивается при наличии в кристалле дефектов. Поэтому наблюдаемая температурная зависимость $\epsilon(T)$ вблизи перехода соразмерная — несоизмерная фаза иная при охлаждении образца, чем при его нагревании (рис. 4).

Рис. 4. Температурная зависимость $\epsilon(T)$ в области фазового перехода соразмерная (полярная) — несоизмерная фаза при нагревании и охлаждении кристалла.



При охлаждении в нек-рой области темп-р в полярной соразмерной фазе наблюдается большая величина ϵ . Это объясняется тем, что доменные стенки, существовавшие в несоизмерной фазе в качестве равновесных

образований, остаются в нек-ром числе и в полярной фазе (как долгоживущие неравновесные образования) и их смещение под действием поля обеспечивают высокую ϵ . После выдержки в полярной фазе число доменных стенок уменьшается (в идеальном случае оно должно было бы стать равным 0), и при нагревания в полярной фазе новые стенки не появляются вплоть до темп-ры, когда становится выгодным их рождение.

В несоизмерной фазе при повышении темп-ры расстояние между доменными стенками уменьшается и в конце концов становится сравнимым с шириной стенки. Распределение поляризации в пространстве становится синусоидальным, а при дальнейшем увеличении T амплитуда синусоиды уменьшается и обращается в 0 в точке фазового перехода из несоизмерной в неполярную фазу.

Микроскопическая теория. Изменение структуры неполярной фазы, переводящее её в полярную фазу, может быть описано как смещение ионов, сопровождающееся деформацией их электронных оболочек, или упорядочение нек-рых ионных групп, занимающих в неполярной фазе нек-з. эквивалентных положений. В первом случае принято говорить о фазовых переходах (системах) типа смещения, во втором — типа порядок — беспорядок. Чёткой границы между этими двумя типами систем не существует, поскольку в любом случае речь идёт об усреднённой во времени структуре. Фактически системы типа порядок — беспорядок можно выделить тем, что в них имеются ионы, для к-рых среднеквадратичное отклонение от ср. положения аномально велико.

Свойства двух предельных типов систем отличаются количественно: различны и механизмы сегнетоэлектрич. фазовых переходов в них. Для кристаллов типа смещения характерно наличие в спектре колебаний кристаллич. решётки «мягкой моды» — предельного оптич. колебания, частота к-рого ω_0 сильно уменьшается при приближении к точке перехода неполярная — полярная фаза.

Системы типа смещения. В системах типа смещения изменение параметра порядка Q (компоненты \mathcal{P}) может быть приближённо описано ур-нием:

$$\ddot{m}\eta + L\dot{\eta} = -\partial\Phi/\partial\eta, \quad (6)$$

где \ddot{m} — эфф. масса осциллятора (колеблющейся подрешётки), L — кинетич. коэффициент. Учитывая ур-ние (1), получаем:

$$\ddot{\eta} + g\dot{\eta} + \omega_0^2\eta = 0, \quad (7)$$

где $g = L/\ddot{m}$ — эфф. коэффициент трения, ω_0 — собств. частота осциллятора, равная

$$\omega_0^2 = \alpha(T - T_K)/\ddot{m} \quad \text{при } T > T_K; \\ \omega_0^2 = -2\alpha(T - T_K)/\ddot{m} \quad \text{при } T < T_K. \quad (9)$$

Наличие мягкой моды в спектре колебаний решётки С. типа смещения, для к-рого справедливо ур-ние (6), следует из теории Ландау: собств. частота осциллятора ω_0 , соответствующая параметру порядка Q , обращается в 0 в точке фазового перехода. Зависимости типа (8), (9) наблюдались в колеб. спектрах многих С. для оптич. мод. Однако в большинстве случаев наблюдается более сложная картина эволюции колеб. спектра вблизи T_K , т. к. ур-ние (6) является приближённым.

Причины неустойчивости кристаллич. решётки относительно смещений ионов, приводящей к спонтанной электр. поляризации, сложны, т. к. связаны с учётом всех сил, действующих между ионами. Для ионных кристаллов особую роль играют кулоновские силы; в частности, диполь-дипольные взаимодействия ионов могут давать отрицательный, дестабилизирующий вклад в суммарную потенциальную энергию кристаллич. ре-

шётки. Поле, действующее на ион, смещённый из положения равновесия так, что образуется точечный диполь, можно представить в виде:

$$E = E_{\text{макро}} + E_{\text{микро}}, \quad (10)$$

где $E_{\text{макро}}$ — макроскопич. деполаризующее поле, обусловленное связанными зарядами на поверхности кристалла (его можно устранить, покрыв кристалл проводящей плёнкой), $E_{\text{микро}}$ — часть поля, не зависящая от формы кристалла. Как показал Лоренц, $E_{\text{микро}} = \beta\mathcal{P}$, где β — коэф., зависящий от структуры кристалла и от точки внутри элементарной ячейки, в к-рой определяется E . В центре ячейки простого кубич. кристалла $\beta = 4\pi/3$. Т. о., энергия электростатич. взаимодействия, приходящаяся на один диполь, равна:

$$U_{\text{эл.ст}} = -\frac{1}{2}E_{\text{микро}}\mathcal{P} = -\frac{1}{2}\beta\mathcal{P}^2. \quad (11)$$

Если в отсутствие кулоновского диполь-дипольного взаимодействия устойчива симметричная конфигурация атомов, то потенциальная энергия, приходящаяся на элементарную ячейку, обусловлена др. короткодействующими силами:

$$U_{\text{кор}} \approx \frac{1}{2}a\eta^2, \quad a > 0, \quad (12)$$

где η — относит. смещение атомов разного типа из симметричных положений, a — коэф., описывающий короткодействующие силы некулоновского происхождения.

При наличии кулоновской составляющей k (12) необходимо добавить (11) и с учётом того, что $\mathcal{P} = e\eta/v_{\text{яч}}$, полный потенциал равен

$$U_{\text{полн}} \approx \frac{1}{2}(a - \beta e^2/v_{\text{яч}}^2)\eta^2. \quad (13)$$

Из ф-лы (13) видно, что диполь-дипольное взаимодействие даёт дестабилизирующий вклад и, если $a < \beta e^2/v_{\text{яч}}^2$, то центр. положение подрешётки рассматриваемых ионов энергетически невыгодно, так что при $T = 0$ К кристалл находится в менее симметричной конфигурации с $\eta \neq 0$.

Системы типа порядок — беспорядок. Для систем типа порядок — беспорядок характерно существование для определённых ионных подрешёток или молекулярных комплексов потенциального рельефа с двумя минимумами (рис. 5). Для обычных кристаллов со сла-



Рис. 5. Потенциальный рельеф, в котором происходит движение ионов в упорядоченной подрешётке в системах типа порядок — беспорядок.

бым ангармонизмом колебаний кристаллической решётки такая ситуация невозможна вплоть до темп-ры плавления. Выше точки фазового перехода каждый атом неупорядоченной подрешётки находится с равной вероятностью $W_I = W_{II}$ в одном из двух положений равновесия; при $T = 0$ К все атомы находятся в одинаковых «правых» или «левых» минимумах. Темп-ре сегнетоэлектрич. фазового перехода отвечает ситуация, когда благодаря взаимодействию между упорядочивающимися частями $W_I \neq W_{II}$.

Система может быть приближённо описана гамилтоном (см. *Изинга модель*):

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{R, R'} J_{RR'} \sigma_R \sigma_{R'}, \quad (14)$$

где $\sigma_R, \sigma_{R'}$ — величины, принимающие значения $+1$ (положение I) или -1 (положение II), набор k -рых даёт полную картину положений атомов в неупорядоченной подрешётке, $J_{RR'}$ — постоянная, описывающая взаимодействие частей, находящихся в положениях,

определяемых векторами R и R' . Расчёт Φ в приближении самосогласованного молекулярного поля приводит к выражению типа (1), где

$$\rho_z = \frac{N_1 - N_{T1}}{N} \frac{e\phi}{v_{\text{вн}}}.$$

Здесь e — заряд неупорядоченной частицы; N_1 , N_{T1} — ср. числа частиц в положениях I, II (рис. 5), $T_{R1} = \int J_{R1} / k$, где $J_0 = \int_{\text{вн}} J_{R1}$.

Для систем типа порядок — беспорядок постоянная Кюри — Вейса обратно на 2—3 порядка меньше, чем для систем типа смещения. Изменение энтропии S на 1 частицу при переходе от полного беспорядка ($T > T_R$) к полному порядку ($T = 0 \text{ К}$) $\Delta S = k \ln 2$; затухание тепловых флуктуаций параметра порядка η носит релаксационный характер.

Несмотря на традиц. представления о природе сегнетоэлектрич. свойств, уровень понимания сущности явления пока недостаточен. В частности, не решена общая проблема предсказания свойств кристалла исходя из его хим. состава и структуры. Не существует методов расчёта констант гамильтониана для С. типа смещения или типа порядок — беспорядок; нельзя привести ни одного примера, когда открытие нового С. шло по пути направленного получения вещества с заранее заданными свойствами и темп-рой фазового перехода.

Однако кол-во С. непрерывно увеличивается, гл. обр. за счёт поиска новых материалов среди соединений, близких по составу и структуре к известным С. Появляются и новые классы С.; обнаружено дипольное упорядочение, близкое к сегнетоэлектрическому, в нек-рых типах синтетических жидких кристаллов и полимеров; создаются композиционные материалы, свойства к-рых можно направленно изменять, варьируя состав сегнетоэлектрич. наполнителя и полимерной или стеклянной матрицы, а также характера связности.

Применение. С. широко используются в технике. Области их применения связаны с аномально большими значениями ϵ (конденсаторы, вариконды), пиро-, пьезоэлектрических, электрострикционных, электрооптич. постоянных, обусловленных наличием фазового перехода, а также с использованием явления переключения спонтанной поляризации. Используются пьезооптич. свойства С. (см. *Нелинейная оптика*).

Большое значение имеет сегнетоэлектрич. керамика, используемая для создания электромагнитических и механоэлектрич. преобразователей в широком диапазоне частот. К ним относятся излучатели звука (см. *Излучатели звука*), датчики микропеременей, гидрофоны, акселерометры, стабилизаторы частоты и т. д. (см. *Пьезоэлектрические преобразователи*). В них в качестве осн. материала служат керамика на основе системы $Pb(TiZr)_2O_8$ (PZT) с разл. добавками, твёрдые растворы сложного состава с размытым фазовым переходом [напр., $Pb(Mg_{1-x}Nb_x)_2O_8$ (PMN) с $T_R = 0^\circ \text{С}$. см. *Пьезоэлектрические материалы*].

В микроэлектронике С. пока не нашли столь обширных применений, как полупроводники, поскольку электронные устройства на С. плохо поддаются интеграции. Однако решены нек-рые технол. проблемы, связанные с получением тонких плёнок С. разного состава (в т. ч. PZT) со свойствами, близкими к монокристаллам. Переключение поляризации в таких плёнках толщиной 50—5000 Å осуществляется малыми электр. напряжениями; плёнки могут наноситься на полупроводниковые подложки. Системы оперативной памяти на основе тонких сегнетоэлектрич. плёнок перспективны. В устройствах интегральной оптики используются волновоодные каналы на поверхности С., к-рые создают путём диффузного легирования кристаллов, гл. обр. ниобата и танталата лития.

Лит.: Иона Ф. Ширани Д., Сегнетоэлектрические кристаллы, пер. с англ., М., 1965; Лайнс М., Глаусс А., Сегнетоэлектрики и родственные им материалы, пер. с англ., М., 1981; Барфут Д., Тейлор Д., Полиэри дивелетри-

ки и их применения, пер. с англ., М., 1981; Струков В. А., Леваяк И. П., Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах, М., 1933; Физика сегнетоэлектрических явлений, под ред. Г. А. Смоленского, Л., 1965; Реев И. С., Готтляуб Ю. М., Дивелетрици. Основные свойства и применения в электронике, М., 1989; Фесенко Е. Г., Гавриличенко В. Г., Семенчев А. Ф., Доменная структура многослойных сегнетоэлектрических кристаллов, Ростов н/Д., 1990; Лайнс М., Тейлор Д., Леваяк В. А., Струков В. А., Сегнетоэлектрические домены — см. Домены, Сегнетоэлектрики.

СЕДИМЕНТАЦИЯ (от лат. sedimentum — оседание) — оседание частиц дисперсной фазы в гравитационном поле или поле центробежных сил, обусловленное различием плотностей этой фазы и дисперсионной среды. С. может приводить к расслоению дисперсной системы. Простейший случай С. — оседание взвешенных (в жидкости или газе) твёрдых частиц в гравитационном поле; по скорости оседания частиц можно установить их размеры и гидродинамич. свойства.

С. макромолекул в центрифуге при высоких значениях центробежного ускорения — один из осн. методов определения мол. массы, распределения по массам, размеров, формы и гибкости макромолекул.

СЕЙСМОЛОГИЯ (от греч. seismos — колебание, землетрясение и logos — слово, учение) — наука о землетрясениях (З.). Осн. задачи, решаемые С.: исследование структуры земных недр и процессов в очагах З., разработка методов уменьшения ущерба от сильных З. (сейсмич. районирование и прогноз З.), мониторинг (слежение, наблюдение) испытаний атомного оружия. Сейсмич. методы широко применяются при разведке полезных ископаемых, в частности нефти. С. стала интенсивно развиваться после 1889, когда в Потсдаме с помощью чувствит. маятников было зарегистрировано сильное З. в Японии.

Регистрация землетрясений. Регистрация упругих волн, вызванных З. или взрывом, выполняется с помощью графа и м. Как правило, сейсмич. observations осущаётся сейсмографами, регистрирующими три компонента смещения: вертикальную, север — юг и восток — запад. Осн. элементом сейсмографа является массивное тело, крепящееся к корпусу прибора пружиной. При смещении корпуса, жестко связанного с Землёй, это тело стремится сохранить прежнее положение. Смещения тела относительно корпуса преобразуются в электрич. сигналы и регистрируются в аналоговом или цифровом виде. Нам. смещения, регистрируемые сейсмографами, сравнимы с межтонами расстояниями (10⁻⁶ м), динамик. диапазон достигает 140 дБ.

Сейсмические волны. Упругие волны, регистрируемые сейсмографами, принадлежат к неск. типам. По характеру пути распространения волны делятся на объёмные и поверхностные. В свою очередь объёмные волны подразделяются на продольные (Р) и поперечные (S), а поверхностные — на *Рассеянные волны* и *Ловя волны*. Объёмные волны распространяются по всё объёму Земли, за исключением жидкого ядра, не пропускающего поперечные волны. Продольные волны связаны с изменением объёма и распространяются со скоростью $V(\lambda + 2\mu)/\rho$, где λ — модуль сжатия, μ — модуль сдвига (см. *Модули упругости*), ρ — плотность среды. Поперечные волны не связаны с изменением объёма, их скорость равна $V\mu/\rho$. Движение частиц в волне S происходит в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. В сферически-симметричных моделях Земли луч, вдоль к-рого распространяется волна, лежит в вертикальной плоскости. Составляющая смещения в волне S в этой плоскости обозначается SV, горизонтальная составляющая — SH. Нек-рые обломки Земли обладают упругой анизотропией; в этом случае поперечная волна расщепляется на две волны с разл. поляризациями и скоростями распространения. Параметры земных недр изменяются по вертикали и горизонтально. Поэтому в процессе распространения объёмные волны испытывают отражение, преломление, обмен (превращение P в S и наоборот), а также дифракцию и

рассеяние. В результате записи З. (сейсмограмма) на большом расстоянии от источника распадается на ряд волновых пакетов или фаз. Отжоджделение фаз и определение координат источника выполняются с помощью набора стандартных таблиц (годографов), задающих время пробега как ф-цию пройденного рассеяния и глубины источника.

Поверхностные волны формируются в результате интерференции объёмных волн и распространяются в верх. оболочке Земли, эфф. толщина к-рой зависит от периода колебаний. Характерной особенностью поверхностных волн является дисперсия скоростей. Поверхностные волны Лява и Рэлея различаются скоростью распространения и поляризацией колебаний. Траектория частицы в волне Рэлея имеет составляющие SV и вертикальную; волны Лява имеют поляризацию SH .

Частотный спектр сейсмич. колебаний лежит в диапазоне от сотен Гц до $\approx 3 \cdot 10^{-4}$ Гц. Колебания с частотами порядка сотен Гц регистрируются только вблизи источника. В НЧ-область (периоды порядка сотен секунд и более) сейсмич. волны приобретают характер собств. колебаний упругого шара. Собств. колебания Земли делятся на сферические, имеющие поляризацию волн Рэлея, и крутильные с поляризацией волн Лява. Известный к настоящему времени спектр сферических и крутильных колебаний Земли насчитывает неск. тысяч собств. частот.

Сейсмология и строение Земли. Представления о внутр. строении Земли в очень большой степени основаны на сейсмич. данных. В соответствии с этими данными Земля разделяется на кору, мантию, жидкую внешнюю и твёрдую внутреннюю части ядра. Кора отделяется от мантии границей Мохоровичича, находящейся под океанами на глубине ~ 10 км и погружающейся под материками до глубин порядка неск. десятков км. В большей части мантии скорости упругих волн растут с глубиной; исключениями являются зона на глубинах 100—300 км и слой D'' в подошве мантии. Наб. рост наблюдается на глубинах 300—700 км, называемых зоной фазовых переходов или переходовой зоной. Резкое увеличение скоростей происходит на сейсмич. границах, находящихся на глубинах ок. 400—650 км; последняя часто рассматривается как граница между верхней и нижней частями мантии.

Механизм добротности мантии различна для продольных и поперечных волн; слой пониженной скорости на глубинах 100—300 км одновременно является зоной пониженной добротности. Пониженной добротностью характеризуется также внеш. зона внутр. ядра. Вопросы зависимости добротности от частоты носят дискуссионный характер.

Сейсмич. исследования структуры глубоких земных недр тесно связаны с изучением конвекции, к-рая приводит в движение литосферные плиты и контролирует т. о. тектонику, активность Земли. Трёхмерные модели Земли в целом и более детальные модели отд. регионов строятся методами сейсмич. *томографии*. Использование этих моделей при геодинамич. построениях опирается на связь скоростей распространения упругих волн с темп-рой и плотностью среды. Наб. контрастные неоднородности скоростей распространения волн обнаруживаются в верхних (≈ 300 км) слоях мантии и в зоне D'' . Важным объектом сейсмич. исследований являются образования с высокими скоростями распространения волн, связанные с погружёнными в мантию плитами океанич. литосферы; эти неоднородности прослеживаются до глубины не менее 1000 км. Объектами структурных исследований являются также рельефы границы ядро — мантия и др. сейсмич. границ. Направление течений в мантии оценивается по характеру связанной с ними упругой анизотропии, обусловленной упорядоченной ориентировкой кристаллов.

Сейсмичность и сейсмический очаг (источник сейсмич. волн). З. представляют одно из проявлений тектоники, активности Земли. По глубине очага З. разделяются

на неглубокие, промежуточные (до 300 км) и глубокие. Макс. глубина очагов глубоких З. ок. 700 км; почти все они сосредоточены в области Тихоокеанского пояса. Происхождение глубоких З. связывают с разрядкой упругих напряжений в погружающихся плитах океанич. литосферы. Большинство неглубоких З. (глубина очага до 80 км) происходит у границ литосферных плит и связано с разрядкой упругих напряжений, накапливающихся при относ. движении блоков литосферы. Ок. 75% энергии неглубоких З. высвобождается в подошве, омываемой Тихий океан, и ок. 20% — в Альпийском поясе, протянувшегося от Средиземноморья до Гималаев. Помимо Тихоокеанского и Альпийского поясов местом сосредоточения большого числа неглубоких З. являются средино-океанич. хребты. Кроме З. у границ литосферных плит известны сравнительно немногочисленные внутриплитовые З.

Величину З. характеризуют параметр, называемый магнитудой (M) и оцениваемый по ф-ле вида

$$M = \lg(a/T) + C,$$

где a — амплитуда смещения в поверхностных волнах, T — период преобладающих колебаний, величина C учитывает зависимость амплитуды смещений от расстояния. Аналогичная классификация производится по наблюдениям P -волн. Практич. магнитуда оценивается по записям мн. сейсмич. станций. Удобство классификации З. по магнитуде объясняется тем, что величина M тесно связана с величиной высвобождаемой при З. упругой энергии E . Одна из ф-л, связывающих энергию (в эргах) с M , имеет вид

$$\lg E = -12,24 + 1,44M.$$

Магнитуда сильнейших З. близка к 9, а соответствующая энергия $\sim 10^{28}$ эрг. В ср. по Земле число З. N связано с магнитудой M соотношением вида

$$\lg N = c - bM,$$

где c и b — постоянные ($b \approx 1$). Т. о., число З. логарифмически растёт с уменьшением магнитуды. Суммарная сейсмич. энергия почти полностью определяется несколькими сравнительно малочисленными сильнейшими З.; оном, как правило, относится к категории неглубоких.

Для целей сейсмостойкого строительства чрезвычайно важны записи ускорений движения грунта в районе, окружающем очаг З. Такие записи получают с помощью спец. инструментов, рассчитанных на большие смещения, чем обычные сейсмографы. Однако инструментальные данные во мн. случаях оказываются недостаточны. Поэтому интенсивность сотрясений, вызванных З., измеряется в баллах по 12-балльной шкале. Балл обочек устанавливается по характеру повреждения построек и результатам опроса очевидцев. Сравнение с инструментальными данными показывает, что балл пропорционален логарифму макс. ускорения грунта. Результаты картографирования балла в области, окружающей очаг З., представляются в виде схемы изосейст.

Кроме магнитуды и балльности очага З. характеризуются рядом др. параметров, устанавливаемых в результате интерпретации сейсмограмм. Большинство результатов в этой области получено с помощью модели очага в виде разрыва со смещением по внутр. поверхности (дислокац. модель). Анализ излучения в разл. направлениях от источника позволяет установить плоскость разрыва и направление подвижки по разрыву. Результаты такого анализа для З. в разл. районах Земли послужили одним из аргументов, обосновавших широкое признание идей тектоники плит. В случае волн, длина к-рых много больше возбуждающего их разрыва, эквивалентом очага служит двойная пара сил, а из наблюдений определяется сейсмич. момент M_0 . $M_0 = \mu \times \text{сдвиг} \times \text{площадь разрыва}$. Характерные значения M_0 лежат в диапазоне от 10^{20} дин-см (Чилийское З., 1960) до 10^{23} дин-см (для микроземлетрясений). При наблюдениях в КВ-области выясняется, что сильное З. является

результатом неск. или многих элементарных сдвигов. Общая длина разрыва для таких З. иногда достигает сотен км; вспарывание разрыва происходит со ср. скоростью, близкой к скорости распространения поперечных волн.

Сейсмическое районирование и прогноз землетрясений. Сильные З. часто происходят в малонаселённых районах, и приносимый ими ущерб невелик. Однако рост городов и строительство сейсмоопасных объектов (атомные электростанции, хим. заводы, высокие плотины) увеличивают сейсмич. опасность. Так, при Тайшаньском З. 28 июля 1976 в Китае погибло неск. сотен тысяч человек. При Спиттакском З. в Армении (1988) погибло неск. десятков тысяч человек, материальный ущерб достиг мн. млрд. рублей. Радикальный способ привоствоза к сильным З. — сейсмостойкое строительство. Высокая стоимость этого строительства вымывает необходимость районирования тектонически активных территорий по степени сейсмич. опасности. Оценка макс. балла для опред. территории основана на опыте, свидетельствующем, что сильные З., как правило, происходят на разломах земной коры, уже неоднократно породивших похожие З. в прошлом. Характерный интервал времени между сильными З. на одном и том же участке разлома определяется индивидуальными особенностями разлома и может варьировать в пределах от десятков до тысяч лет. Сильные З., происшедшие в доисторич. времена, оставили следы на местности, распознавание и интерпретация к-рых выполняется методами палеосейсмологии.

Предсказание З. — сложнейшая задача З. Для того чтобы предсказание имело практич. смысл, оно должно содержать три характеристики будущего З.: время, место, силу. Различают долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный прогнозы З. Соответствующие сроки находятся в пределах от неск. лет до десятков лет, от неск. недель до неск. лет, менее неск. недель. Существ. прогресс достигнут только в долгосрочном прогнозе сильных З. Особенно полезной оказалась идея сейсмич. брешей: сильнейшие ($M \sim 8$) З. Тихоокеанского пояса происходят таким образом, что очаг каждого нового З. заполняет область, где такого З. не было в течение последних ~ 100 лет. Идея брешей позволила сделать неск. оправдавшихся долгосрочных прогнозов.

Краткосрочные прогнозы основаны на аномальных изменениях разл. геофиз. полей и деформациях земной поверхности, изменениях уровня грунтовых вод и их темп. состава, появлении предварающих толчков — форшоков. Трудности прогноза связаны с тем, что явления-предвестники трудно отличить от фоновых вариаций полей. Известен только один беспорный случай успешного краткосрочного прогноза, позволившего принять меры для спасения населения: предсказание Хайцзинского З. (1975) с магнитудой 7,3 в китайской провинции Ляонин. Решающим фактором в этом прогнозе было появление форшоков. Разработка эфф. методов краткосрочного прогноза требует диат. и систематич. изучения З. и предварающих их явлений в разл. геологич. условиях.

При подводных З. опасность представляют очень длинные волны на поверхности воды — цунами. В наиб. степени воздействию цунами подвержены берега Тихого океана. Сравнительно низкая скорость распространения этих волн позволяет заблаговременно предупредить население о приближении цунами.

К проблеме сейсмич. опасности примыкает вопрос о техногенных З. Известно три вида деятельности человека, провоцирующей З.: заполнение крупных водохранилищ, закачка воды в скважины для увеличения нефтедачи и добыча твёрдых полезных ископаемых в большой глубине. Возникающие при этом З. обычно относятся к категории слабых.

Мониторинг ядерных взрывов. Наиб. эфф. метод дистанционного мониторинга подземных ядерных испытаний — сейсмический. Мониторинг имеет две ста-

дии: обнаружение сейсмич. сигналов и распознавание взрывов среди З. Осп. критерий распознавания взрывов основан на различиях в пространственных координатах источников: ок. 90% всех сейсмич. событий идентифицируются как З. просто потому, что они происходят или слишком глубоко, или в районах, негнригодных для ядерных испытаний. Сейсмич. источник типа взрыва представляет центр расширения и этим принципиально отличается от сдвигового дислокации, моделирующей очаг З. Это приводит к ряду отличий в параметрах соответствующих волновых полей. Трудности распознавания возникают в случае слабого сигнала, когда наблюдаются только малая часть волнового поля.

Возможности регистрации слабых сигналов лимитируются сейсмич. шумом. Наиб. сила этого шума (микросейсм.) достигает в периоды 5–8 с. Осн. источником микросейсм с периодами более 1 с служат волновые поверхности воды на обширных акваториях. На периодах менее 1 с в сейсмич. шуме присутствует техногенная составляющая.

Внеземная сейсмология. В кон. 1960-х гг. амер. экспедициями на Луне были размещены 5 сейсмич. станций, к-рые регистрировали ежегодно от 800 до 3000 слабых лунотрясений. Лунные сейсмограммы резко отличались от земных очень длительной реверберацией, объясняемой высокой добротностью верх. оболочки Луны. Лунотрясения происходят на глубинах до 400 км и от 800 до 1000 км. Толчки второй (более глубокой) группы происходят преим. в те периоды, когда Луна максимально приближается к Земле. По сейсмич. данным, лунная кора имеет мощность от 60 до 100 км; на глубинах от 500 до 1000 км имеется зона повышенной скорости упругих волн.

В 1978 космич. аппаратом «Викинг» сейсмограф был установлен на поверхности Марса. Из-за высокого уровня помех ветрового происхождения достоверных данных о сейсмичности Марса получить не удалось.

Эфф. методом изучения внутр. структуры и динамики Солнца является *солнечная сейсмология*.

Сейсмическая разведка. Сейсмич. методы находят широкое применение при исследовании структуры верх. части земной коры в связи с поисками полезных ископаемых, особенно нефти и газа. Сейсмич. колебания возбуждаются взрывами или механич. устройствами; сейсмоприёмники размещаются на поверхности Земли или в стволах скважин. Для картирования подземных структур используются преим. отражённые волны. Наиб. распространением пользуется методика общей глубинной точки. В этой методике для получения каждой точки отражающей границы служат записи большого числа источников и приёмников. Методы сейсморазведки широко применяют также для исследования структуры земной коры на всю её глубину.

Лит.: Аги К., Ричардс П., Количественная сейсмология, пер. с англ., т. 1–2, М., 1983; Мого К., Предсказание землетрясений, пер. с англ., М., 1988. Л. П. Вышinsky.

СЕЙФЕРТОВСКИЕ ГАЛАКТИКИ — спиральные галактики с активными ядрами. Названы по имени К. Сейфerta (C. Seyfert), обнаружившего в 1942 в спектрах десятка ярких спиральных галактик сильные эмиссионные линии водорода и др. элементов. С. г. (SyG) составляют подкласс объектов с активными ядрами. Поскольку такие объекты выделяются, как правило, по спектральным признакам, нет чёткого разграничения между SyG и квазарами (QSO). Напр., SyG I Zw 136 входит в список ярких квазаров, а квазар 3C 273 иногда включается в списки SyG. Хотя в ср. ширине водородных линий в спектрах квазаров значительно больше, чем в спектрах ядер SyG, пек-рые SyG по ширине линий сравнимы с квазарами. Возможно, квазары также являются активными ядрами спиральных галактик, т. к. у ряда квазаров обнаружены окружающие галактики, по пек-рым характеристикам — спиральные. Во мн. отношениях квазары и ядра SyG сходны между собой, так что в каталогах

квазары и SyG часто разделяют только по светимости (абс. звездной величины M): SyG при $M > -23^m$; OSO при $M < -23^m$. Одно из осн. отличий — это контраст (отношение) светимостей ядра и всей галактики. Светимость ядер SyG составляет $\approx 20\%$ от полной светимости галактики, у квазаров — больше 90%. С этим связаны некие особенности ядер SyG: низкая степень поляризации излучения, порядка неск. процентов (у квазаров и «лацертид» до 30%); увеличение амплитуды переменности (в звездных величинах) с уменьшением диаметра диафрагмы (с K -рой проводится наблюдение) и длины волны (в УФ-диапазоне амплитуда значительно больше, чем в видимом) и др. Соответственно меняются и показатели цвета (см. Астрометрия) ядер SyG при изменении блеска: в максимум блеска они близки к показателям цвета квазаров ($U - B \approx -1^m$, $B - V \approx 0^m$), в минимуме — к показателям цвета спиральных галактик ($Sa - Sb$).

По виду спектра SyG делятся на три типа: Sy1 (широкие разреженные и узкие запрещенные линии), Sy2 (и те и др. линии узкие) и Sy3 («лацнери» — линии узкие, относительно велика интенсивность линий низкой ионизации). По этим признакам OSO можно отнести к типу Sy1. Кроме спектральных особенностей галактики Sy1 и Sy2 отличаются и др. характеристиками. Так, мощность рентг. излучения Sy1 в ср. на порядок больше, чем Sy2, амплитуда оптич. переменности также значительно больше, присутствует быстрая (характерное время $t < 14$ д) переменность излучения. С др. стороны, галактики Sy2 в ср. имеют более мощное радиоизлучение, более крутой спектр в ИК-диапазоне (что обусловлено в осн. тепловым излучением пыли), тогда как ИК-спектр Sy1 более плоский и ближе к спектру квазаров.

Наблюдаясь неоднократно переходы (по спектральным характеристикам) Sy1 в Sy2 (NGC4151) и наоборот (NGC1566) подтверждают общность природы ядер SyG разных типов и доминирующую роль центр. источника. Исследование именно SyG позволяет, видимо, решить проблему связи активности ядра с галактикой в целом. Существуют две точки зрения на проявление феномена активного ядра: SyG — фаза в эволюции любой спиральной галактики (короткая шкала жизни), SyG — особый класс объектов, отличающихся от «нормальных» спиральных галактик (длинная шкала). Если SyG, за исключением активного ядра, ничем не отличаются от «нормальных» спиральных галактик, то, видимо, справедлива первая точка зрения. Интенсивные исследования SyG (с кон. 1960-х гг.) дают свидетельства скорее в пользу второй гипотезы. Прежде всего, SyG отличаются от «нормальных» спиральных галактик того же морфологич. типа повыш. концентрацией поверхностной яркости. На расстояниях 1—40 кпк от ядра распределение поверхностной яркости спиральных галактик по радиусу r можно представить как r^{-2} . Показатель степени n для SyG в 1,5 раза больше, чем для нормальных спиральных галактик. Т. к. поверхностная яркость галактики определяется звездной, то, во-первых, повыш. концентрация яркости означает повыш. концентрацию массы, а во-вторых, исключает гипотезу короткой шкалы жизни активного ядра, $\sim 10^8$ лет, поскольку звездная составляющая галактики не может перераспределиться за столь короткое время. Следовательно, время жизни активного ядра должно быть порядка возраста галактики, $\sim 10^{10}$ лет, т. е. SyG — особый класс объектов, а не фаза в эволюции любой спиральной галактики. Возможно, именно повыш. концентрация массы и порождает активное ядро.

Корреляция неких характеристик ядер с градиентом поверхностной яркости также указывает на связь активности ядра с галактикой в целом. Зависимость от наклона галактики к лучу зрения отношения потока в эмиссионной линии H_α к рентг. потоку свидетельствует о плоской конфигурации области формирования широких линий, параллельную диску галактики. За-

висимости амплитуды медленной составляющей переменности ядер Sy1 от наклона галактики указывает на то, что область формирования оптич. континуума (непрерывного спектра) также имеет плоскую структуру (возможно, аккреционный диск), параллельную плоскости галактики.

С. г., объекты типа BL Lac и квазары составляют, по-видимому, единую популяцию объектов с активными ядрами, природа центр. источников активных ядер также, скорее всего, одинакова. Разные наблюдательные проявления их обусловлены разл. дорожшт. условиями — мощностью излучения, контрастом ядра, наклоном к лучу зрения, циклами активности и т. д.

Литт. см. при ст. Объекты с активными ядрами.

СЕКТОРНАЯ СКОРОСТЬ — величина, характеризующая скорость возрастания площади, K -ую ометает радиус-вектор r движущейся точки, проведенный из некоего фиксиров. центра O . Численно С. с. v_s равна отношению элементарного приращения площади dA к соответствующему элементарному промежутку времени dt . С. с. можно представить в виде вектора v_s , направленного перпендикулярно к площадке dA ; при этом $v_s = [r\dot{\theta}]/2$, где v — вектор скорости точки, т. е. С. с. равна половине момента скорости точки относительно центра O . Если точка движется по плоской кривой и ее положение определяется полярными координатами r и φ , то $v_s = (1/2)r^2 d\varphi/dt$. Производная от С. с. по времени наз. с е к т о р н ы м у с к о р е н и е м в т о ч к и $\omega_s = [r\dot{\theta}]/2$, где ω — угловая скорость точки.

Понятие о С. с. играет важную роль при изучении движения под действием центр. сил, т. к. в этом движении С. с. остается величиной постоянной.

СЕКУНДА [от лат. *secunda divisio* — второе деление (первоначально градуса, а затем и часа)] ($e, s, 1$) единица времени СИ. Различают: а) м е ж д у с., воспроизводимую цезиевыми атомными часами τ ; времени: э ф е м е р и д н ы ю С., размер K -рой связан с периодом обращения Земли вокруг Солнца (впервые установлен на основании астр. наблюдений). Атомная С. равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего энергетич. переходу между двумя уровнями сверхтонкой структуры осн. состояния атома цезия ^{133}Cs (резолюция 13-й Генеральной конференции по мерам и весам, 1967). Эталон времени и частоты (включая оптич. атомно-лучевую трубку с пучком атомов Cs и радиоустройством, дающее набор электр. колебаний фиксиров. частот) позволяет воспроизводить единицы времени и частоты с относит. погрешностью $\pm 1 \cdot 10^{-14}$. За эфемеридную С. принята 1/31556925,9747 доля года. Атомная и эфемеридная С. совпадают с точностью $\sim 2 \cdot 10^{-9}$.

2) Звездная С. равна 1/86400 звездных суток и составляет 0,99726966 атомной (эфемеридной) С.

3) Угловая С. ($^{\circ}$) — внесистемная единица плоского угла. $1^{\circ} = (1/3600)^{\circ} = 4,848137 \cdot 10^{-8}$ радиан.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ в оптической спектроскопии — описывает способность спектрального прибора выделять узкие спектральные интервалы $\Delta\lambda$ из сплошного спектра излучения в окрестности длины волны λ . Количественно характеризуется величиной $S = \lambda/\Delta\lambda$. При полном подавлении излучения посторонних длин волн и при идеальном механизме сканирования численные значения S совпадают со значениями разрешающей способности $R = \lambda/\Delta\lambda_{\text{эф}}$, где $\Delta\lambda_{\text{эф}}$ — ширина апаратной функции. В применении к узкополосным интерференционным фильтрам отношение $\lambda/\Delta\lambda$ иногда наз. д о б р о т н о с т ь ю.

СЕЛЕКЦИЯ МОД — прореживание спектра мод (собств. колебаний и волн) в системах с большим числом степеней свободы. Примером С. м. может служить удаление боковой стенки у эл.-магн. резонатора цилиндрич. конфигурации (рис. 1). Эта операция вносит большие

излучат. (дифракц.) потери в моды, образованные лучами с большим наклоном к оси системы, сохраняя относительно малое затухание (высокую добротность) лишь для мод, образованных лучами, почти перпендикулярными зеркалам. Благодаря этому зеркальный резонатор способен резонировать на дискретных, изо-

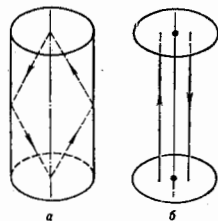
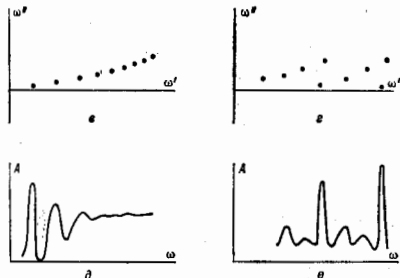


Рис. 1. Прореживание спектра мод при замене закрытого (а) резонатора открытым (б): ω , ω' — собственные частоты $\omega = \omega' + i\omega''$ резонаторов, θ , θ' — амплитуды колебаний в резонаторах как функции частоты ω возбуждающего сигнала.



лиров. частотах в существенно более высокочастотной области спектра, чем исходный закрытый резонатор (на рис. 1 и далее зависимость полей от времени принята в виде $\text{Re}\{A e^{i\omega t}\}$).

Селективными свойствами обладает и зеркальный волновод (рис. 2), обеспечивающий малые излучат. потери для осев. моды (с простейшей, «одногорбой» поперечной структурой поля) и большие потери для мод

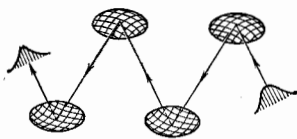


Рис. 2. Зеркальный волновод.

высших моды (с «многогорбой» поперечной структурой поля). Это стабилизирует структуру волнового потока и снижает искажения передаваемого сигнала.

Селективные свойства могут быть приданы волноводом и резонатором и закрытого типа — с пед. подбором формы (напр., волноводы П- и Н-образного сечения) и пед. расположением поглощающих вставок.

К С. м. прибегают при создании генераторов и усилителей любых типов (электронных вакуумных приборов, приборов нолупроводниковой электроники, лазеров и т. п.) для обеспечения пространственно-временной

когерентности выходного сигнала в режимах большой мощности. Простейшей моделью (рис. 3) могут служить два колебательных контура, нагруженных на общий активный (с проводимостью отрицат. знака) элемент: подбором соотношений между параметрами реактивных, диссипативных и активного элементов можно

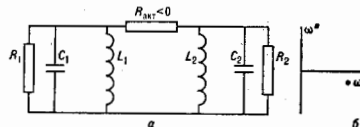


Рис. 3. Система колебательных контуров с общим активным ($R_{\text{акт}} < 0$) элементом и спектр её нормальных мод — затухающей ($\omega'' > 0$) и нарастающей ($\omega'' < 0$) во времени.

добиться того, чтобы на уровне малого сигнала условие нарастания $\omega'' < 0$ выполнялось лишь для одной из нормальных (связанных) мод системы. Даже если условие нарастания выполнено сразу для обеих мод, то при увеличении амплитуды автоколебаний нелинейность, присущая любой реальной активной среде, порождает взаимодействие (конкуренцию) «горячих» мод, что при определёл. условиях может привести к установлению режима генерации единств. моды.

Возможности С. м. в генераторах и усилителях мощного излучения расширяются в случаях, когда проводимость активной среды обладает резонансной зависимостью от частоты или (и) — в случае среды с пространственной дисперсией — от постоянной распространения волны. Для С. м. используются и геом. факторы — различия в связи между активной средой и модами, обладающими разной пространственной структурой.

В природных условиях проявления С. м. можно посмотреть в структурах ветровых волн и перистых облаков, НЧ-колебаниях ионосферы под действием солнечного ветра и др. колебательно-волновых процессах с узкими частотными спектрами и узкой направленностью. С С. м. связаны и нек-рые случаи сверхдальнего распространения звуковых волн (типа аффекта шепчущей галереи).

Лит.: В а я ш т е й н Л. А. Электромагнитные волны, 2 изд., М., 1988; Y a r i v А., Introduction to optical electronics, 2 ed., N. Y.—la. o.l. 1976; К о в а л е в Н. Ф., П е т е л и н М. И., Селекция мод в высокочастотных релятивистских электронных генераторах с распределенным взаимодействием, в кн.: Релятивистские высокочастотные электроники, Горький, 1981; К а р л о в Н. В., Лекции по квантовой электронике, 2 изд., М., 1988; Н. Ф. К о в а л е в, М. И. П е т е л и н. СЕЛЕН (Selenium), Se.— хим. элемент VI группы периодич. системы элементов, ат. номер 34, ат. масса 78.96. Природный С.— смесь 6 изотопов: ^{74}Se , ^{76}Se — ^{78}Se , ^{80}Se и ^{82}Se , в к-рой преобладает ^{80}Se (49,7%), а меньше всего ^{74}Se (0,9%). Конфигурация внеш. электронных оболочек атома $4s^2 4p^4$. Энергии последоват. ионизации 9,752; 21,2; 32,0; 42,9 и 68,3 эВ соответственно. Атомный радиус 0,16 нм, радиус ионов Se^{4+} 0,069 нм, Se^{2-} 0,193 нм. Значение электроотрицательности 2,48. Сродство к электрону 2,02 эВ.

С. образует неск. полиморфных модификаций, наиб. устойчивая кристаллич. модификация — т. н. серый С. с гексагональной решёткой (постоянные решётки $a = 0,4363$ нм, $c = 0,4959$ нм). Плотность серого С. 4,807 кг/дм 3 . Красный С. имеет моноклинную решётку, существующую в α -форме ($a = 0,9054$ нм, $b = 0,9083$ нм, $c = 1,801$ нм, угол $\beta = 90^\circ 42'$) и β -форме ($a = 0,931$ нм, $b = 0,807$ нм, $c = 1,285$ нм, $\beta = 93^\circ 08'$). Существуют также стекловидные (аморфные) С. чёрного цвета и аморфный С. красного цвета. Все эти модификации при длит. хранении и выдерживании при темп-рах 100—150 $^\circ\text{C}$ переходят в гексагональную модификацию (серый С.). Серый С. имеет $t_{\text{пл}} = 221$ $^\circ\text{C}$, $t_{\text{кип}} = 685,3$ $^\circ\text{C}$,

уд. теплоёмкости $c_p = 25.3$ Дж/моль·К, его теплопроводность 6.7 кДж/моль, теплота испарения 30 кДж/моль, темп-ра Дебая 89 К. Уд. электрич. сопротивление $8 \cdot 10^{-4}$ Ом·м (при 0°C), термич. коэф. электрич. сопротивления $0.6 \cdot 10^{-3}$ К $^{-1}$ ·С. — полупроводник, ширина запрещённой зоны серого С. 1.8 эВ, аморфного С. (в виде плёнки) — 2.2 – 63 эВ. Твёрдый С. диамантист, парф С. нарамагнитен. Диэлектрич. проводимость аморфного С. 6.24 (при 290 К). Тв. по Бриллюэлю серого С. ~ 750 МПа, модуль нормальной упругости при растяжении 10.2 ГПа, модуль сдвига 6.6 ГПа.

В соединениях проявляет свойства аналогичные ± 2 , ± 4 и ± 6 . Химически активен по свойствам аналогичен S. Парф С. содержит молекулы разл. состава, между к-рыми может установиться равновесие: $\text{Se}_2 \rightleftharpoons \text{Se}_6 \rightleftharpoons \text{Se}_8 \rightleftharpoons \text{Se}_n$. С. и его соединения ядовиты.

Из С. изготовляют выпрямители, его применяют в полупроводниковой электронике. Высокие фотоэлектрич. свойства используют в селеновых фоторезисторах. Путём введения С. в стёкла создают оптич. материалы, поглощающие ИК-излучение. С. применяют также в металлургии, в резинотехн. пром-сти и для др. целей. В качестве радиоакт. индикатора служит ^{76}Se (электронный захват, $T_{1/2} = 119.8$ сут).

С. С. Верёвников.

СЕНСИБИЛИЗАТОРЫ — то же, что *кумюлянты*.

СЕНА ЭФФЕКТ (астафетное движение ионов) — перенос заряда при движении атомных ионов в обств. газе, определяющийся резонансной *перезарядкой иона* на обств. атоме. Установлен Л. А. Сенвой в 1947. Обычно сечение этого процесса значительно превосходит сечение упругого рассеяния иона на атоме, упругое рассеяние несущественно в переносе заряда. При небольших напряжениях E ион электр. поля, когда направленная скорость ионов значительно превышает тепловую скорость атомов, перенос заряда носит астафетный характер. А именно: после очередной перезарядки ион практически останавливается, т. к. приобретает скорость атома, на к-ром произошла перезарядка. Далее вновь образовавшийся ион ускоряется во внеш. электр. поле до следующей перезарядки. В сильных электр. полях скорость астафетного направленного движения ионов пропорц. $(E/p)^{1/2}$, а в слабых — E/p (p — давление газа).

Лит.: Сен и Л. А. Стожиковий, электроны и ионы в атомном газе, Л.—М., 1948; Смирнов В. М., Физика слабоионизованного газа в задачах с решениями, 3 изд., М., 1985.

В. М. Смирнов.

СЕН-ВЕНАНА ПРИНЦИП в теории упругости — принцип, согласно к-рому уравновешенная система сил, приложенная к к-л. части поверхности однородного упругого тела, вызывает в нём напряжения, быстро убывающие по мере удаления от этой части. На расстояниях, больших макс. линейных размеров области приложения нагрузок, напряжения и деформации оказываются пренебрежимо малыми. Т. о., С.-В. п. устанавливает локальность эффекта самоуравновешенных внеш. нагрузок. Сформулирован А. Сен-Венаном (A. Saint-Venant) в 1855.

Часто пользуются др. редакцией С.-В. п., а именно: если условия, действующие на небольшую часть упругого тела, заменить другой, статически эквивалентной системой усилий (т. е. системой, имеющей ту же равнодействующую и тот же момент, что и заданная сила), действующей на ту же часть поверхности тела, то изменение в напряжённом состоянии произойдёт лишь в непосредств. близости и области приложения нагрузки; в точках же упругого тела, удалённых от места приложения усилий на расстояния, достаточно большие по сравнению с линейными размерами той поверхности, к к-рой они приложены, влияние перераспределения усилий будет ничтожно. Т. о., С.-В. п. позволяет одиң граничные условия (действующие силы) заменять другими (напр., более удобными для статич. расчёта) при условии, что равнодействующая и гл. моменты позад заданной системы сил сохраняют свои

значения. С.-В. п. применяется также при наличии упругопластич. деформаций.

Лит.: Тимошенко С. П., Гудьер Дж., Теория упругости, пер. с англ., М., 1975.

СЕНСИБИЛИЗАТОРЫ (от лат. sensibilis — чувствительный) — вещества, способствующие повышению чувствительности др. веществ к к-л. внеш. воздействию. С., напр., являются атомы благородных металлов и т. в. полиметиновые красители, повышающие светочувствительность галогенного серебра в фотоматериалах в ДВ-области спектра. С. в *кристаллофосфорах* служат атомы-дворцы, поглощающие энергию возбуждения и передающие её безызлучательно атомам-акцепторам, в к-рых происходит излучат. переход (т. н. *сенсбилизированная люминесценция*).

СЕНСИБИЛИЗОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, возникающая в результате переноса энергии электронного возбуждения от одних оптич. центров (наз. *дворцами* или *сенсбилизаторами* энергии) к другим (наз. *центрами* свечения или *акцепторами* энергии). В результате такого переноса в оптич. центрах возбуждения люминесценция появляется новая, обычно более интенсивная полоса, обусловленная поглощением энергии в сенсбилизатор. центрах, тогда как спектр люминесценции определяется энергетч. структурой центров свечения. Поэтому спектральные, иеронные и поляризац. свойства С. л. существенно отличаются от свойств обычной люминесценции; они сильно зависят от механизма переноса энергии возбуждения (резонансно-индукционный, обменный, резонансно-индуц. кооперативный и т. д.), реализуемого в данной системе, от концентрации центров, их взаимного расположения и индивидуальных характеристик, а также условий возбуждения системы (напр., темп-ры).

С. л. наблюдается в разл. системах — порошкообразных кристаллофосфорах, молекулярных и диэлектрич. (лазерных) кристаллах, стёклах с редкоземельными ионами, тонких плёнках, растворах красителей, газах — при повышении нек-рых критич. значений концентрации взаимодействующих центров. Она применяется для повышения эффективности использования возбуждающего излучения (в поликристаллич. люминофорах для люминесцентных ламп, в т. в. миграционных лазерах и т. д.), для контроля или изучения взаимодействия оптич. центров в разл. средах (напр., при люминесцентном анализе биол. объектов). Пары оптич. центров подбирают таким образом, чтобы ионы сенсбилизирующего вещества хорошо поглощали возбуждающее излучение, а ионы, образующие центры свечения, испускали излучение с необходимыми характеристиками. Так, в типичных сенсбилизаторах люминофорах — сложных (напр., иттрий-скандий-галлиевых) граватах — светл. лампы какнаки эффективно поглощаются ионами Ce^{3+} , а индукторы, переходы возникающие в ионах Nd^{3+} , обладающих предпочтительной для генерации излучения четырёхуровневой системой. В люминесцентных лампах используют, напр., пары ионов Ce^{3+} — Mn^{2+} или Pr^{3+} — Mn^{2+} , в к-рых сенсбилизирующий ион (Ce^{3+} или Pr^{3+}) хорошо поглощает узкополосное УФ-излучение тлеющего разряда и почти полностью передаёт энергию возбуждения иону Mn^{2+} . В люминесцентном анализе находят применение пары красителей (напр., теазол жёлтый и уранин), позволяющие по соотношению интенсивностей полос актиатора и сенсбилизатора замечать уже небольшие изменения взаимного расположения их молекул (за десятк. н. А), что, напр., делает возможным изучать динамику мышечных сокращений.

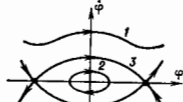
С. л. обычно сопровождается значит. уменьшением интенсивности люминесценции сенсбилизирующих ионов, так что общий квантовый выход люминесценции не увеличивается, а в большинстве случаев несколько понижается. Однако в нек-рых системах (напр., в системах с редкоземельными ионами) при введении сенс-

билдзаватора удаётся получить и увеличение общего квантового выхода за счёт понижения вероятности относительно к-л. безызлучат. процесса релаксации энергии возбуждения.

Лит.: К. Константинова-Шлезингер М. А., Химия ламповых гетеросмесических люминофоров, 1970; Гранович В. М., Галанин М. Д., Перенос энергии возбужденного возбуждения в конденсированных средах, М., 1978; Карнаухов В. Н., Люминесцентный спектральный анализ катиона, М., 1978. Ю. П. Тимофеев.

СЕПАРАТРИСА (от лат. *separari*) — траектория динамической системы с двумерным фазовым пространством, стремящаяся к седловому состоянию равновесия при времени $t \rightarrow \infty$ (устойчивая С.) или при $t \rightarrow -\infty$ (неустойчивая С.). Если С. стремится к седлу при $t \rightarrow \pm \infty$, то её (вместе с седлом) называют петлей С. [1, 2]. В диссипативных динамич. системах из петли С. может рождаться предельный цикл [2]. В консервативных динамич.

Развёртка фазового цилиндра уравнения (а); траектории отеческая колебания по углу (1) и вращательному моменту (2) движения; 3, 4 — сепаратрисы.



системах петли С. могут разделять фазовое пространство на области с разл. поведением траекторий. Напр., на фазовом цилиндре (рис.) динамич. системы, описываемой ур-нием маятника

$$d^2\varphi/d\xi^2 + a \sin \varphi = 0, \quad (*)$$

две петли С. отделяют область колеб. траекторий от области вращат. движений маятника (см., напр., [3]). Для динамич. систем с размерностью фазового пространства, большей двух, устойчивые и неустойчивые многообразия седловых состояний равновесия и (или) седловых предельных циклов наз. многомерными С. или сепаратрисными многообразиями. Многомерные С. могут разделять фазовое пространство на области притяжения разл. аттракторов. Связанные с сепаратрисными многообразиями бифуркации могут приводить к возникновению странных аттракторов; напр., аттрактор Лоренца рождается в момент, когда неустойчивые С. седла пересекаются устойчивыми сепаратрисными многообразиями седловых предельных циклов.

Решения, отвечающие С., часто встречаются в разл. физ. приложениях. Они, в частности, описывают класс уединённых волн (солитонов) в нелинейных средах с дисперсией, а также разл. рода доменные стенки, дислокации, дисцилиации и др. дефекты в таких средах.

Лит.: 1) Качественная теория динамических систем второго порядка, М., 1966; 2) Теория бифуркаций динамических систем на плоскости, М., 1967; 3) Рабинович М. И., Трубенцов Д. И., Введение в теорию колебаний и волн, М., 1984; 4) Браун А., Патерно Д., Эффект Дюффинсона: физика и приложения, пер. с англ., М., 1984. В. С. Бибихин, Ю. С. Сера (Sulfur), S — хим. элемент VI группы периодич. системы элементов, ат. номер 16, ат. масса 32,066. Природная С. — смесь 4 изотопов: ^{32}S , ^{34}S и ^{36}S . В к-рой преобладает ^{32}S (95,02%), а меньше всего ^{36}S (0,02%). Конфигурация внеш. электронных оболочек $3s^2 3p^4$. Энергия последоват. ионизации 10,360; 23,35; 34,8; 47,30 и 72,5 эВ соответственно. Атомный радиус 0,104 нм, радиус иона S^{2-} 0,174–0,182 нм, S^{4+} — 0,034 нм. Значение электроотрицательности 2,5–2,6. Сродство к электрону 2,077 эВ.

Образует ряд полимерных модификаций. До 95,6 °С устойчива лимонно-жёлтая модификация (α -S) с ромбич. решёткой, её постоянные $a = 1,04646$ нм, $b = 1,28660$ нм, $c = 2,44860$ нм; плотн. 2,085 кг/дм³ (20 °С), $t_{пл} = 112,8$ °С, $t_{кип} = 444,6$ °С. При темп-рах 95,0–119 °С устойчива медово-жёлтая модификация (β -S) с моноклинной решёткой, её постоянные $a = 1,090$ нм, $b = 1,096$ нм, $c = 1,102$ нм, угол

$\beta = 86,16$. Плотн. β -S 1,96 кг/дм³ (20 °С). При темп-ре выше 119,3 °С β -S переходит в жидкую модификацию λ -S, резкое охлаждение к-рой позволяет получить аморфно-красную пластич. модификацию μ -S. Известны и др. модификации С.

Для α -S уд. теплоёмкость $c_p = 22,61$ Дж/моль·К, теплота плавления 49,82 кДж/К (при 385,8 К); для β -S $c_p = 23,65$ Дж/моль·К, теплота плавления 38,52 кДж/К (при 392,3 К). Модификации α -S и β -S нерастворимы в воде, но хорошо растворяются в сероуглероде CS_2 . С. — диэлектрик. Ширина запрещённой зоны для α -S 2,6 эВ, диэлектрич. проницаемость 3,6–4,0 (при 566 К). Твёрдая С. — диамантетики, молекулы S_2 в парах парамагнитны. Теплопроводность монокристаллич. С. 0,46–0,48 Вт/м·К (10–15 °С), аморфной С. — 0,2094 Вт/м·К. Термич. коэф. линейного расширения для α -S $7,4 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$, для β -S $8 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$. Показатель преломления α -S 2,0377, β -S 1,96. Модуль нормальной упругости 18 ГПа.

В хим. соединениях проявляет степени окисления от -2 до +6, наиб. характерны -2, +4, +6. Химически активна, при нагревании реагирует с подавляющим большинством элементов. В парах С. возможно равновесие $\text{S}_2 \rightleftharpoons \text{S}_3 \rightleftharpoons \text{S}_4 \rightleftharpoons \text{S}_6$.

Сульфид цинка ZnS и сульфид кадмия CdS — типичные люминофору. H_2SO_4 — сильная кислота. Гексафторид серы SF_6 — газообразный диэлектрик, используемый в качестве активной среды в хим. лазерах. С. применяется также в сельском хозяйстве, резиновой промышленности искусств. волокон, взрывчатых веществ, промышленности органич. синтеза, медицине и др. В качестве радиоакт. индикатора используют β -радиоакт. радиоизотоп ^{35}S ($T_{1/2} = 87,44$ сут).

С. С. Боровосое.

СЕРБЕРО (Argentum), Ag, — хим. элемент побочной подгруппы I группы периодич. системы элементов, ат. номер 47, ат. масса 107,8682, благородный металл. Природное С. — смесь ^{107}Ag (51,839%) и ^{109}Ag (48,161%). Известно с древности. Конфигурация внеш. электронных оболочек $4s^2 3d^9 4p^6 5s^1$. Энергия последоват. ионизации 7,576; 21,487; 34,83 эВ. Энергия сродства к электрону 1,30 эВ. Радиус атома Ag 0,144 нм, иона Ag^+ 0,113 нм. Значение электроотрицательности 1,42.

В свободном виде С. — мягкий белый металл, обладающий кубич. гранецентриров. решёткой с параметром $a = 0,40862$ нм. Плотн. 10,49 кг/дм³, $t_{пл} = 961,9$ °С, $t_{кип} = 2170$ °С, теплоёмкость $c_p = 25,3$ Дж/(моль·К), теплота плавления 11,3 кДж/моль, теплота испарения 266,8 кДж/моль. Темп-ра Дебая 225,3К. Высоко электро- и теплопроводно. уд. электрич. сопротивление 0,162 мкОм·м (при 0 °С), 0,0285 мкОм·м (при 200 °С), 0,0475 мкОм·м (при 500 °С); температурн. коэф. электрич. сопротивления $4,1 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (при 0 °С), теплопроводность 453,0 Вт/(м·К) (при 0 °С). Термич. коэф. линейного расширения $18,8 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (при 300 К), $24,3 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (при 900 К). Обладает высокой отражат. способностью; С., осаждённое в вакууме на стекло, отражает 95% видимого света, 98% ИК-излучения, 10% УФ-излучения.

Высокопластичный ковкий, тягучий металл; механич. свойства зависят от условий обработки. Для С., охлаждённого при 800 °С, модуль нормальной упругости 72–75 ГПа, модуль сдвига 28–27 ГПа, твёрдость по Бринеллю 255–256 МПа. В хим. соединениях проявляет степень окисления +1, реже +2, +3 и (очень редко) +4. Химически малоактивен, не окисляется кислородом воздуха, при длит. хранении в атм. воздухе медленно покрывается тёмной плёнкой Ag_2S . Бромид С. AgBr , а также хлорид AgCl , иодид AgI и др. — светочувствит. соединения. Металлич. С. применяется в качестве проводника и контакта в ответственных узлах аппаратуры, из него изготавливают металлы ал.-тех. приборов, электроды, хим. посуду, зеркала. С. входит в состав разл. припоев, используемых для низкотемпературной пайки сталей, медных и др. сплавов. Эл.-хим. се-

ребрение предохраняет металлич. поверхности от коррозии. Сплавы С. с Pd, Pt и др. благородными металлами обладают высокой коррозионной стойкостью. Светлоустойчив. соединения применяют в фото- и киноматериалах. Прозрачные для ИК-излучения AgCl и некоторые др. соединения используют в ИК-приборах. В качестве радиоакт. индикатора служит β -радиоактивный ^{108}Ag ($T_{1/2} = 249,9$ сут.). Широкое применение С. обусловлено его дефицитностью и быстрорастущую стоимостью, а также необходимостью утилизировать все содержимое С. детали из приходящей в негодность аппаратуры, отработанные растворы фиксажа и т. д.

С. С. Вербоноев.

СЕРОЕ ТЕЛО — тело, *положения коэффициента* k -рого меньше 1 и не зависит от длины волны излучения λ и абс. темп-ры T . Коэф. поглощения $\alpha_{\lambda,T}$ (наз. также коэф. черноты С. т.) всех реальных тел зависит от λ (селективное поглощение) и T , поэтому их можно считать серыми лишь в интервалах λ и T , где коэф. $\alpha_{\lambda,T}$ прил. постоянен. В видимой области спектра свойствами С. т. обладают каменный уголь ($\alpha_{\lambda,T} = 0,80$ при 400—900 К), сажа ($\alpha_{\lambda,T} = 0,94-0,96$ при 370—470 К); платиновая и висмутовая черни поглощают и излучают как С. т. в наиб. широком интервале λ — от видимого света до 25—30 мкм ($\alpha_{\lambda,T} = 0,93-0,99$).

С. т. является источником т. и. серого излучения — теплового излучения, одинакового по спектральному составу с излучением абсолютно черного тела, но отличающегося от него меньшей энергетич. яркостью. К серому излучению применимы законы излучения абсолютно черного тела — *Планка закон излучения, Вина закон излучения, Рэлея — Джинса закон излучения*. Появляе С. т. применяется в *пирометрии оптической*.

СЕЧЕНИЕ (эффективное сечение) — величина, характеризующая вероятность перехода системы двух сталкивающихся частиц в результате их рассеяния (упругого или неупругого) в определенное конечное состояние. С. σ равно отношению числа dN таких переходов в единицу времени к плотности n потока рассеиваемых частиц, падающих на мишень, т. е. к числу частиц, проходящих в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную к их скорости v (n — плотность числа падающих частиц): $d\sigma = dN/nv$. Т. о., С. имеет размерность площади. Разл. типам переходов, наблюдаемых при рассеянии частиц, соответствуют разные С. Упругое рассеяние частиц характеризуют дифференциальным сечением $d\sigma/d\Omega$, равным отношению числа частиц, упруго рас-

сеянных дифференциального сечения, взятому по полному телесному углу. На рис. схематически изображен процесс упругого рассеяния точечных «классич.» частиц на шарике радиуса R_0 с «абсолютно жесткой» поверхностью; полное С. рассеяния равно геом. сечению шарика: $\sigma = \pi R_0^2$.

При наличии неупругих процессов полное С. складывается из С. упругих и неупругих процессов. Для более детальной характеристики рассеяния вводят С. для отд. типов (каналов) неупругих реакций. Для *многочисленных процессов* важное значение имеют т. н. и. к. л. в. в. и. е. сечения, описывающие вероятность появления в данном столкновении к.-л. определ. частицы или группы частиц.

Если взаимодействие между сталкивающимися частицами велико и быстро падает с увеличением расстояния, то С. по порядку величины, как правило, равно квадрату радиуса действия сил или геом. сечению системы; однако вследствие специфич. квантовомехан. явлений С. могут весьма существенно отличаться от этих значений (напр., в случаях резонансного рассеяния и *Рамазурра эффекта*).

Эксперим. измерения С. рассеяния дают сведения о структуре сталкивающихся частиц. Так, измерения угл. зависимости С. упругого рассеяния α -частиц атомами позволили открыть атомное ядро, а С. упругого рассеяния электронов нуклонами — определить радиусы нуклонов и распределение в них электрич. заряда и магн. момента (т. н. эл.-магн. *форм-факторы*). Изучение С. *слабого неупругого процесса* рассеяния лептонов на нуклонах обнаружило составляющие их «точечные» частицы достаточно малых размеров — *нуртоны*.

В квантовой теории С. равно квадрату модуля *амплитуды рассеяния*. Полное С. рассеяния связано с мнимой частью амплитуды упругого рассеяния на нулевой угол *оптической теоремой*.

Понятие С. используется также в кинетич. ур-ниях, описывающих неравновесные процессы в статистич. физике.

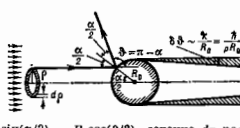
С. С. Герштейн.

СЖАТИЕ — см. *Растяжение*.

СЖАТОЕ СОСТОЯНИЕ электромагнитного поля — состояние поля, при к-ром дисперсия флуктуаций канонически сопряженных компонент поля не равна. Возможны классич. и квантовые С. с. В первом случае оказываются неравными дисперсии квадратур классич. флуктуаций (см. [1], с. 125); для квантового С. с. дисперсия любой одной канонически сопряженной компоненты меньше дисперсии в когерентном состоянии. Понятие С. с. возникло в процессе изучения (1960—70-е гг.) статистич. характеристик излучения (долазерные эксперименты по коррелиям интенсивности), детального исследования необычных свойств лазерного света. Различают С. с. квадратурно-сжатые и состояния с подавленными флуктуациями числа фотонов или состояния.

Для когерентного состояния поля характерно пуассоновское распределение фотонов $p(n) = (\bar{n}^n/n!)e^{-\bar{n}}$ с дисперсией $\sigma^2 = \bar{n}$. В поле с меньшей дисперсией флуктуаций подавлены квантовые флуктуации интенсивности, *статистика фоточетов* сглажена во времени. В этом случае распределение фотонов более узкое, чем пуассоновское, и такое поле наз. с. б. пуассоновским. Уровень шума детектирования излучения с субпуассоновской статистикой фотонов оказывается ниже уровня *дрового шума*. Поэтому использование эл.-магн. полей с субпуассоновской статистикой представляет интерес для высокоустойчив. и высокоточных измерений, в оптич. связи и спектроскопии.

Схематичное представление С. с. на фазовой плоскости дано на рис. 1. Векторами обозначены ср. амплитуды, пунктиром — область неопределенности *когерент-*



Схема, поясняющая упругое рассеяние «классич.» частицы на «абсолютно твердом» шарике. Рассеяние на угол $\theta = \pi - \alpha$ отвечает прицельный параметр $\rho = R_0 \sin(\alpha/2) = R_0 \cos(\theta/2)$, сечение $d\sigma$ рассеяния в телесный угол $d\Omega = 2\pi \rho d\rho$ равно площади заштрихованного кольца: $d\Omega = 2\pi \rho d\rho = (\pi/2) R_0^2 \sin^2 \theta d\theta$, т. е. дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega = R_0^2/4$, а полное сечение упругого рассеяния равно геом. сечению шарика: $\sigma = \pi R_0^2$. При учёте неупругих (волновых) свойств частиц сечение получается иным. В предельном случае $\lambda \gg R_0$ ($\lambda = \lambda/\nu$ — длина волны де Бройля частицы, ν — её импульс) рассеяние сферически симметрично, а полное сечение в 4 раза больше классического: $\sigma = 4\pi R_0^2$. При $\lambda < R_0$ рассеяние на конечные углы ($\theta \neq 0$) напоминает классическое, однако под очень малыми углами $\theta \sim \lambda/R_0$ происходит волновое «дифракционное» рассеяние с сечением πR_0^2 ; т. о., полное сечение с учётом дифракции вдвое больше классического $\sigma = 2\pi R_0^2$.

сеянных в единицу телесного угла, к потоку падающих частиц ($d\Omega$ — элемент телесного угла), и по λ и ν упругим сечением σ , равным интегралу

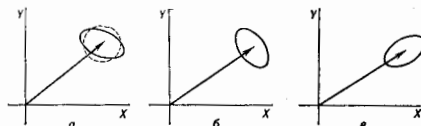


Рис. 1. Схематичное представление сжатых состояний электромагнитного поля на фазовой плоскости: а — произвольная ориентация эллипса сжатия; б — подавлены амплитудные флуктуации; в — подавлены фазовые флуктуации.

ного состояния, эллипсами — области неопределённости С. с. При соответствующей ориентации эллипса сжатия относительно регулярной составляющей поля возможно подавление как амплитудных (рис. 1, б), так и фазовых (рис. 1, в) флуктуаций.

В квантовой оптике напряжённость однодмодового электрич. поля описывается оператором

$$\hat{E} = C[\hat{X} \sin(\omega t - kz) + \hat{Y} \cos(\omega t - kz)],$$

где \hat{X} и \hat{Y} — операторы квадратур:

$$\hat{X} = (a + a^\dagger)/2, \quad \hat{Y} = (a - a^\dagger)/i2,$$

ω — частота, k — волновое число, z — направление распространения излучения, $C = \text{const}$, а и a^\dagger — операторы уничтожения и рождения фотона. Операторы квадратур удовлетворяют коммутат. соотношению $[\hat{X}, \hat{Y}] = i/2$, а их дисперсии $\sigma_X^2 = \langle \Delta \hat{X}^2 \rangle$, $\sigma_Y^2 = \langle \Delta \hat{Y}^2 \rangle$ — соотношению неопределённости

$$\frac{\sigma_X^2 \sigma_Y^2}{X Y} \geq 1/16,$$

$\Delta \hat{X} = \hat{X} - \langle \hat{X} \rangle$, $\langle \hat{X} \rangle = \langle \Psi | \hat{X} | \Psi \rangle$, $|\Psi\rangle$ — вектор состояния поля, $\langle \dots \rangle$ — квантовомеханич. усреднение. В когерентном и вакуумном состояниях $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = 1/4$. В квантовом С. с. флуктуация одной из квадратур, напр., $\sigma_X^2 < 1/4$, тогда как $\sigma_Y^2 > 1/4$ или наоборот.

В случае классич. флуктуаций операторы a , a^\dagger заменяются комплексными амплитудами A , A^* , при этом квадратуры

$$X = (A + A^*)/2, \quad Y = (A - A^*)/i2.$$

При классич. сжатии $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$.

Поля в С. с. являются периодическими нестационарными [1], в чём легко убедиться, используя классич. описание. Полагая квадратуры некоррелированными, для ср. интенсивности поля имеем:

$$\langle E^2 \rangle = \left[\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + \left(\sigma_Y^2 - \sigma_X^2 \right) \cos 2(\omega t - kz) \right] / 2.$$

Методы получения сжатых состояний основываются на нелинейных радиофиз. и оптич. процессах. В оптике С. с. может возникать в трёх- и четырёхчастотных параметрич. взаимодействиях (см. *Взаимодействие световых волн*), при генерации высших гармоник, в эффектах самодействия, комбинац. рассеяния, многофотонных процессах и т. п. Возможно также непосредств. создание высокостабильных лазерных источников излучения, в к-рых подавление квантовых флуктуаций осуществляется либо депрессией шумов накачки, либо введением отрицат. обратной связи.

Преобразование вакуумного или когерентного состояния, к-рому соответствуют операторы a и a^\dagger , в сжатое (соответственно операторы b и b^\dagger) описывается операторным ур-нием в представлении Гейзенберга:

$$b = \mu a + \nu a^\dagger, \quad b^\dagger = \mu^* a^\dagger + \nu^* a, \quad (1)$$

где μ и ν — постоянные, удовлетворяющие соотношению $|\mu|^2 - |\nu|^2 = 1$. Тогда дисперсии флуктуаций квадратурных компонент

$$\sigma_X^2 = |\mu - \nu|^2/4, \quad \sigma_Y^2 = |\mu + \nu|^2/4. \quad (2)$$

Преобразование вакуумного состояния в сжатое иначе можно записать как [2]:

$$|\alpha, \xi\rangle = D(\alpha) S(\xi) |0\rangle, \quad (3)$$

где $|0\rangle$ — вектор вакуумного состояния, а $D(\alpha)$ и $S(\xi)$ — операторы сдвига и сжатия:

$$D(\alpha) = \exp(\alpha a^\dagger - \alpha^* a), \quad (4)$$

$$S(\xi) = \exp\left(\frac{1}{2} \xi (a^\dagger)^2 - \frac{1}{2} \xi^* a^2\right),$$

а ξ и ξ^* — в общем случае комплексные числа.

Состояние $|0\rangle = S(\xi)|0\rangle$ принято называть вакуумным С. с. ($\alpha = 0$).

С. с. возникает, напр., при вырожденном параметрич. взаимодействии. В поле интенсивной классич. накачки параметрич. усиление слабого сигнала описывается ур-нием для операторов в представлении Гейзенберга:

$$da/dz = \beta a^\dagger, \quad (5)$$

где β — комплексный коэф., зависящий от нелинейных свойств среды и амплитуды накачки. Решение (5) имеет вид:

$$a(z) = a_0 \text{ch } \Gamma z + e^{i\theta} a_0^\dagger \text{sh } \Gamma z, \quad (6)$$

где $\Gamma = |\beta|$, $\theta = \arg \beta$, а операторы a_0 и a_0^\dagger — параметры на входе нелинейной среды.

Операторы квадратур преобразуются следующим образом:

$$\hat{X}(z) = (\text{ch } \Gamma z + \text{coshsh } \Gamma z) \hat{X}_0 + (\text{sinhsh } \Gamma z) \hat{Y}_0, \quad (7)$$

$$\hat{Y}(z) = (\text{ch } \Gamma z - \text{coshsh } \Gamma z) \hat{Y}_0 + (\text{sinhsh } \Gamma z) \hat{X}_0.$$

Аналогичные соотношения получаются и при полностью классическом описании параметрич. усиления (с заменой операторов комплексными амплитудами). Согласно (7), дисперсии квадратур при $\theta = 0$

$$\sigma_X^2(z) = \sigma_X^2(0) e^{2\Gamma z}, \quad \sigma_Y^2(z) = \sigma_Y^2(0) e^{-2\Gamma z}, \quad (8a)$$

а при $\theta = \pi$

$$\sigma_X^2(z) = \sigma_X^2(0) e^{-2\Gamma z}, \quad \sigma_Y^2(z) = \sigma_Y^2(0) e^{2\Gamma z}. \quad (8б)$$

Поведение квадратур, т. о., существенно зависит от фазы накачки θ . Фазовая селективность рассматриваемого параметрич. процесса — важнейшая его особенность, исследованная в радиодиапазоне в пач. 1960-х гг. [4]. Тогда же были продемонстрированы возможности управления статистич. характеристиками эл.-магн. полей, снижения уровня фазовых флуктуаций, улучшения характеристик систем выделения сигнала из шума. Действительно, при соответствующей ориентации эллипса сжатия на фазовой плоскости, регулируемой выбором фазы накачки, подавление флуктуаций квадратуры приводит к снижению фазовых флуктуаций. Это просто показать на примере классич. С. с. Пусть напряжённость поля (эллипс ориентирован вдоль оси X)

$$E = \langle \hat{X} \rangle + \Delta X \sin(\omega t - kz) + \Delta Y \cos(\omega t - kz) \quad (9)$$

или

$$E = \rho \cos \varphi,$$

$$\rho^2 = \langle(X+\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2, \operatorname{tg} \varphi = \langle \Delta Y / (X+\Delta X) \rangle \approx \Delta Y / \langle X \rangle \quad (10)$$

Флуктуации фазы φ связаны с флуктуациями квадратуры Y . Подавление флуктуаций ΔY приводит к изменению функции распределения фазы $w(\varphi)$. В связи с этим основ. метод исследования С. с. в радиодиапазоне состоит в измерении распределения $w(\varphi)$ [4].

Г. возникновению С. с. приводит также эффект с а м о в о з д е й с т в и я. При распространении излучения в среде с кубичной нелинейностью появляется фазовая добавка, пропорц. числу фотонов $n_0 = a^+ a_0$ (эффект фазовой *само модуляции света*). Для одностороннего излучения этот эффект описывается ур-нием

$$a_1(z) = \exp(-i \gamma n_0 z) a_0, \quad (11)$$

где коэф. γ определяется кубичной нелинейностью среды. В случае исходного когерентного состояния $\langle z \rangle$ с амплитудой a , где a — собств. значение оператора $a_0(z) = a|z\rangle$, и оптм. фазы сигнала $\varphi = \operatorname{arg} a$, удовлетворяющей соотношению $\varphi = (1/2) \operatorname{arctg} \psi - \psi$, $\psi = \gamma |a|^2 z$, минимальная дисперсия квадратуры

$$\sigma_X^2 = [(1+\psi^2)^{1/2} - \psi]^2 / 4.$$

При этом дисперсия второй квадратуры максимальна:

$$\sigma_Y^2 = [(1+\psi^2)^{1/2} + \psi]^2 / 4.$$

При нелинейном оптич. преобразовании (11) статистика фотонов не меняется: $n(z) = a^+(z)a(z) = n_0$. Однако интерференция поля, выходящегося в когерентном состоянии, с полем, преобразованным согласно (11), позволяет получить излучение с субгауссоновской статистикой [4].

Для регистрации С. с. оптич. излучении обычно используется балансное гомотинное детектирование (рис. 2). Сжатый свет, к-рому соответствуют операторы

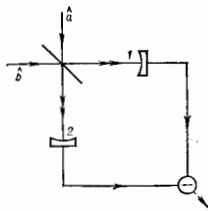


Рис. 2. Схема балансного гомотинного фотодетектирования: 1 и 2 — фотоприёмники в каналах.

a и a^+ , смешивается с мощным когерентным излучением гетеродина (операторы b и b^+). Операторы уничтожения, описывающие излучение в каждом из каналов (индексы «1» и «2») после смешения, имеют вид:

$$a_1 = (a+b)/\sqrt{2}, \quad a_2 = (-a+b)/\sqrt{2}.$$

Для фотоприёмника с единичным квантовым выходом оператор разностного фототока равен

$$I = a_1^+ a_1 - a_2^+ a_2 = a^+ b + b^+ a \approx \langle b \rangle a^+ + \langle b \rangle^* a.$$

Приближённая часть выражения соответствует значению гетеродина в случае, когда его можно описывать классически: $\langle b^+ b \rangle \gg 1$. Подбором фазы гетеродина $\theta = \operatorname{arg} \langle b \rangle$ можно добиться того, чтобы разностный фототок определялся лишь одной из квадратур регистрируемого поля, напр.

$$I = \langle b \rangle (a + a^+) = 2 \langle b \rangle \langle X \rangle,$$

а его дисперсия — дисперсией этой квадратуры:

$$\langle \Delta I^2 \rangle = 4 \langle b \rangle^2 \sigma_X^2.$$

Если на входе гетеродина излучение в С. с. отсутствует, то дисперсия определяется вакуумными флуктуациями ($\sigma_X^2 = 1/4$) и уровень дробового шума описывается ф-лой Шоттки. При подаче на смеситель излучения в С. с. уменьшается дробовой шум детектирования. Др. способ исследования С. с. базируется на регистрации усиленной квадратуры компоненты. При сильном сжатии классич. и многомоновое квантовое С. с. обладает фазосопряжённым спектром, т. е. фазы фурье-компонент поля, расположенных симметрично относительно ср. частоты, комплексно сопряжены (равны но абс. величине, но имеют разные знаки). Это свойство приводит к тому, что при удвоении частоты широкополосного спектра С. с. в спектре второй гармоники формируется очень узкий пик [4]. Квантовая трактовка этого явления — смещение коррелиров. пар фотонов, рождаемых при параметрической люминесценции.

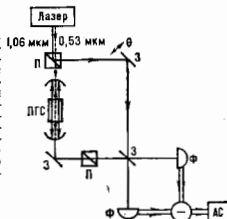


Рис. 3. Схема эксперимента по генерации сжатых состояний: адьюктивный лазер генерирует излучение на длине волны $\lambda = 1,06$ мкм (сплошные линии) и на $\lambda = 0,53$ мкм (штриховая линия); перемещением одного из плоских зеркал вносится фазовая задержка θ ; П — поляризатор; З — зеркало; Ф — фотодиод; АС — анализатор спектра; ПГС — параметрический генератор света.

Ярким подтверждением существования квантовых С. с. явился эксперимент [5], схема к-рого приведена на рис. 3. Здесь реализовано коллинеарное трёхфотонное параметрич. взаимодействие в оптич. резонаторе в донорном режиме. Излучение накачки ($\lambda \approx 0,53$ мкм), представляющее собой вторую гармонику задающего лазера на графите с неодимом, поступает в резонатор, где генерируется С. с. на $\lambda = 1,06$ мкм. Одновременно излучение задающего лазера с $\lambda = 1,06$ мкм отщепляется от оси пучка и смешивается с излучением в С. с. в схеме балансного гомотинного детектирования. Оси. результат эксперимен-

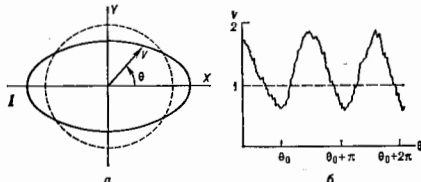


Рис. 4. Зависимость напряжения шумов разностного фототока от фазы гетеродина: а — область квантовой неопределенности; б — результат эксперимента. Пуантирные линии показывают уровень дробового шума и соответствующее ему вакуумное состояние (его область квантовой неопределенности).

та, заключающийся в появлении провалов под уровнем дробового шума, представлен на рис. 4, где изображена зависимость напряжения шума фототока от фазы гетеродина. Глубина провалов составляет прикл. 50%.

Ост. причинами, препятствующими достижению глубокого сжатия, кроме тех шумов являются любые потери малочислен (в т. ч. и вследствие неединичного квантового выхода фотоприёмников), а также многомодовость реальных световых пучков, ограничивающих в пространстве, так и во времени. Деструктивная роль потерь объясняется их вероятностным характером: излучение с нек-рой вероятностью осуществляется излучением априори неизвестных фотонов, и их поток, первоначально определенным образом упорядоченный, приобретает случайный характер, что и снижает глубину сжатия. В многомодовом излучении каждая мода может быть «сжата» по-своему, т. е. иметь разл. эффективность и ориентацию эллипса сжатия на фазовой плоскости. Поскольку при регистрации происходит аддитивное сложение мод, в результирующей картине возникает «размазывание» сжатия. Тем не менее возможно появление С. с. в сверхкоротких импульсах, спектр сжатия к-рых широкополосный. Это выгодно отличается от генерации С. с. в резонаторах, где сжатие проявляется лишь до нанодиапаза МГц.

Эфф. формирование импульсов сжатого света возможно в процессе параметрич. усиления в поле импульсной накачки [6], а также в оптич. солитонах за счёт фазовой самомодуляции [4], необходимой для их формирования.

С. с. эл.-магн. поля достигается также подавлением квантовых флуктуаций в лазерах, при этом, как правило, генерируется свет с субуассоновской статистикой фотонов, являющийся частным случаем С. с. Между интенсивностью генерируемого излучения и накачкой устанавливаются отрицат. обратную связь. Здесь необходимо применение методов квантовых невозмущающих измерений интенсивности, чтобы не разрушить акт измерения субуассоновского состояния. Возможны, напр., два варианта реализации таких измерений. Первый предполагает использование среды с кубичной нелинейностью, в к-рой при распространении генерируемого излучения осуществляется фазовая самомодуляция. Возникающий нелинейный фазовый набег регистрируется при прохождении той же среды слабым пробным пучком с последующим его гетеродинамич. измерением. В результате фазовая модуляция пробного пучка переходит в амплитудную, к-рая и используется в линии отнрицат. обратной связи лазерной накачки. Второй вариант заключается в управлении накачкой невырожденного параметрич. генератора. При этом используются жесткая взаимная корреляция фотонов в сигнальной и холостой волнах: они рождаются только одновременно. Фототок детектора, регистрирующего холостую волну, поступает в линию отнрицат. обратной связи, регулирующей мощность накачки, тем самым стабилизируя амплитуду сигнальной волны. Последнее и приводит к возникновению в ней субуассоновской статистики фотонов.

Генерировать субуассоновский свет можно также стабилизируя квантовые флуктуации тока накачки полупроводникового лазера. Достичь субуассоновской статистики электрич. сигнала (электронов) сравнительно несложно, напр. с помощью эффекта Кулона в электронно-лучевой трубке. При высокой эффективности преобразования заряд. частиц тока накачки в искусственные фотоны (неединичная эффективность эквивалента потерям) субуассоновское состояние накачки переходит в генерируемый свет, т. е. из радиодиапаза в оптич.ский. Можно использовать и обратный фотоэффект Франка — Герца, однако эффективность преобразования при этом оказывается ниже.

Подавление шума, связанного с созданием инверсной населенности в лазере, достигается также применением мощной импульсной периодич. накачки, к-рая переводит все электроны на верх. уровень рабочего перехода. При этом также создаются необходимые предпосылки для генерации субуассоновского света.

До сих пор обсуждалось формирование С. с. эл.-

магн. поля во времени. В общем случае можно говорить о пространственно-временном сжатии [4, 7], характеризующем области пространственных и временных частот, в к-рых квантовые флуктуации подавлены. Наглядным является пример пространственного сжатия при вырожденном параметрич. усилении когерентных волн с неколлинеарной геометрией взаимодействия. Сжатие в сигнальной и холостой волнах в отдельности отсутствует, но оно возникает при их интерференции с разностью фаз, кратной l . В частности, макс. сжатие проявляется в интерференц. максимумах. Число интерференц. полос на единицу длины определяет пространственную частоту сжатия. При параметрич. взаимодействии пучков с конечной апертурой пространственный спектр сжатия, очевидно, более сложен.

Лит.: 1) А. М. Минин, С. А. Дьячков, Ю. Е. Черкин, А. С. Введение в статистическую радиофизику и оптику, М., 1981; 2) Смирнов Д. Ф., Трошин А. С. Новые явления в квантовой оптике, «УФН», 1987, т. 153, с. 233; 3) Клямкин Д. Н., Фотоны и нелинейная оптика, М., 1980; 4) А. М. Минин, С. А. Дьячков, Ю. Е. Черкин, А. С. Физическая нестабильность и мультистабильность в сосредоточенных и распределенных системах: классическая и квантовая аспекты, в кн.: Новые физические принципы оптической обработки информации, под ред. С. А. Азимова, М. А. Воронцова, М., 1980; 5) W. U. L. и др., Generation of squeezed states by parametric down conversion, «Phys. Rev. Lett.», 1986, v. 57, p. 2520; 6) Slusher R. E. и др., Pulsed squeezed light, «Phys. Rev. Lett.», 1987, v. 59, p. 2588; 7) Колдобов М. И., Соколов И. В., Поведение сжатых состояний света в пространстве и квантовые шумы оптических изображений, «ЖЭТФ», 1989, т. 96, с. 1945; 8) Клямкин С. Я., Квантовая оптика. Поля и их детектирование, Минск, 1990; 9) Бемков В. П., Основные особенности сжатого света, «УФН», 1991, т. 161, № 10, с. 145; 10) Ташманов М. К., Салаев Б. Э. А., Сжатые состояния света, «УФН», 1991, т. 161, № 4, с. 161.

А. В. Белашский, А. С. Черныш.
СЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ — проводится при охлаждении их ниже критич. темп-ры T_K (см. Критическая точка). С. г. критич. темп-рой выше темп-ры окружающей среды (Cl_2 , NH_3 , CO_2 и др.) проводится сжатием их в компрессорах и последующей конденсацией в теплообменниках, охлаждаемых водой или холодильным раствором. Для С. г. с критич. темп-рой ниже темп-ры окружающей среды их предварительно охлаждают с помощью соответствующих холодильных (криогенных) циклов.

Идеальный цикл С. г. приведен на рис. 1: 1—2 — изобарич. охлаждение газа от темп-ры T_0 до темп-ры T_K начала конденсации (T_K ниже T_K), изотерма 2—0 — конденсация газа; 0—3 — изотермич. сжатие газа, 3—0 — адиабатич. его расширение. Площадь под 1—2—0

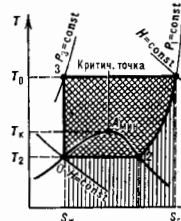


Рис. 1. T — S диаграмма идеального цикла сжижения газов (p — давление, H — энтальпия).

соответствует отводной при С. г. теплоте, площадь внутри 1—2—0—3 — мин. работа $A_{\text{мин}}$ С. г.:

$$A_{\text{мин}} = T_0(S_T - S_{\text{ж}}) - (H_T - H_{\text{ж}}),$$

где S_T , $S_{\text{ж}}$ — энтропия, H_T , $H_{\text{ж}}$ — энтальпия газа и жидкости соответственно.

Давления, необходимые для идеального цикла С. г., составляют сотни тысяч атм, поэтому на практике цикл неосуществим. Реальные затраты энергии при С. г. обычно превышают $A_{\text{мин}}$ в 5—10 и более раз.

Совр. методы С. г. основаны на охлаждении предварительно сжатого газа при Джоуля — Томсона эфф.

факте (т. е. при дросселировании — пропускании газа через пористую перегородку, кран, вентиль), изотропич. расширении газа с совершением внеш. работы в детандере и при выпуске газа из сосуда пост. объёма (выхлоп). Процесс дросселирования необратим, идёт с возрастанием энтропии по закону: $H = \text{const}$. Инверсионная темп-ра всех газов (темп-ра, при к-рой положит. эффект Джоуля — Томсона становится отрицательным и газ начинает нагреваться!), кроме H_2 , Ne и He , на сотни градусов выше темп-ры окружающей среды, и поэтому они могут быть охлаждены и сжижены простым дросселированием. Инверсионные темп-ры H_2 , Ne и He значительно ниже комнатных, поэтому их предварительно охлаждают (H_2 и Ne — жидким азотом, He — жидким водородом).

Термодинамически наиб. эффективен метод С. г. с помощью детандера; этот метод в пром. установках является основным. В поршневых детандерах сжатый газ движет поршень и охлаждается, в турбодетандерах — вращает турбину. В большинстве случаев после детандера газ дополнительно охлаждают дросселированием. Процесс расширения газа в детандере: $S = \text{const}$.

На рис. 2 приведены типовая схема установки для С. г. (а) и $T-S$ -диаграмма (б) термодинамич. процессов в ней. После сжатия в компрессоре (1—2) и предварит. охлаждения на теплообменнике (2—3) поток сжатого газа делится на два: поток M отводится в детан-

Подвергаемые сжатию газы должны быть очищены от примесей, к-рые имеют тем-ру замерзания более высокую, чем в цикле сжижения данного газа, и, затвердевая, могут закупорить теплообменную аппаратуру. Сжижение газов (N, O_2, H_2 , природного газа и др.) — крупная отрасль хим. пром-сти.

Лит.: Справочник по физико-техническим основам криогеники, под ред. М. Д. Малова, 3 изд., М., 1985; Фрадков А. В., Что такое криогеника, М., 1991.

А. Е. Фрадков.

СЖИМАЕМОСТЬ — способность вещества изменить свой объём под действием всестороннего давления. С. обладают все вещества. Если вещество в процессе сжатия не испытывает хим., структурных и др. изменений, то при возвращении внеш. давления к исходному значению нач. объём восстанавливается. Именно обратимое изменение занимаемого веществом объёма V под равномерным гидростатич. давлением p и наз. обычно С. (объёмной упругостью). Величину С. характеризует коэф. С. β , к-рый выражает уменьшение единичного объёма (или плотности ρ) тела при увеличении p на единицу:

$$\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\Delta V}{\Delta p} \right) = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\Delta \rho}{\Delta p} \right),$$

где ΔV и $\Delta \rho$ — изменения V и ρ при изменении p на величину Δp . $K = 1/\beta$ — модуль объёмной упругости (модуль объёмного сжатия, объёмный модуль); для твёрдых тел

$$K = EG/3(3G-E),$$

где E — модуль Юнга (см. *Модули упругости*), G — модуль сдвига. Для идеальных газов $K = p$ при любой темп-ре T . В общем случае С. вещества, а следовательно, K и β зависят от p и T . Как правило, β убывает при увеличении p и растёт с T . Часто С. характеризуют относит. плотностью $\sigma = \rho/\rho_0$, где ρ_0 — плотность при $T = 0^\circ C$ и $p = 1$ атм.

Сжатие может происходить как при пост. T (изотермически), так и с ооодворем. разогрвом сжимаемого тела (напр., в адиабатном процессе). В последнем случае значения K будут большими, чем при изотермич. сжатии (для большинства твёрдых тел при обычной T иа неск. %).

Для оценки С. веществ в широком диапазоне p используют уравнения состояния, выражающие связь между p , V и T . Определяют С. непосредственно по изменению V под давлением (см. *Пьезометр*), из акустич. измерений скорости распространения упругих волн в веществе. Эксперименты в ударной волне позволяют установить зависимость между p и ρ при максимальных экспериментально полученных давлениях. С. находят также из измерений параметров кристаллич. решётки под давлением, производимых методами рентгеновского структурного анализа. С. можно определить, измеряя линейную деформацию твёрдого тела под гидростатич. давлением (по т. л. линейной С.). Для изотропного тела коэф. линейной С.

$$\frac{1}{L} \left(\frac{\Delta L}{\Delta p} \right) \approx \frac{1}{3} \beta,$$

где L — линейный размер тела.

С. газов, будучи очень большой при $p < 1$ кбар, по мере приближения их плотности к плотности жидкостей становится близкой к С. жидкостей. Последняя с ростом p уменьшается сначала резко, а затем меняется весьма мало: в интервале 6—12 кбар уменьшается примерно так же, как в интервале от 1 атм (10^{-3} кбар) до 1 кбар (примерно в 2 раза), при 10—12 кбар составляет 5—10% от нач. значения. При 30—50 кбар модули K жидкостей по порядку величины близки к K твёрдых тел. Для твёрдых тел при 100 кбар $\Delta\rho/\rho_0 \approx 15-25\%$. Для отд. веществ, напр. для шестич. металлов, $\Delta\rho/\rho_0 \sim 40\%$, для большинства др. металлов 6—15%. Линейная С. анизотропных веществ зави-

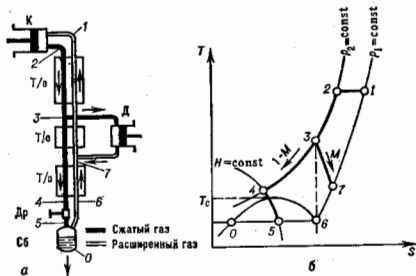


Рис. 2. Схема установки сжижения газов (а) и её $T-S$ -диаграмма (б); К — компрессор, Д — детандер, T_b — теплообменники, Др — дроссель, СБ — сборник.

дер, где, расширяясь, производит работу, охлаждается (3—4) и охлаждает вторую часть сжатого газа 1 — M , к-рой затем дросселируется и сжижается. Теоретиче.ски расширение газа в детандере должно протекать при пост. энтропии (3—6), однако в результате разл. потерь реально идёт процесс 3—7. В крупных установках С. г. применяют неск. детандеров, работающих в разных температурных интервалах. Спец. устройство позволяет получать сжиженный газ непосредственно в самом детандере и обходиться без дросселирующей ступени.

Для сжижения небольших кол-в газа используют криогенно-газовые машины, представляющие собой комбинацию компрессора, теплообменного аппарата и детандера. С. помощью таких машин получают темп-ры до 10 К, т. е. достаточно низкие для сжижения всех газов, кроме гелия (для сжижения гелия пристраивается доплнит. дросселирующая ступень). В небольшом объёме С. г. может производиться при охлаждении испаряющейся жидкостью с более низкой (чем получаемая) темп-рой кипения. Так, с помощью жидкого азота можно сжимать кислород, аргон, метан и др. газы, с помощью жидкого водорода — неон. Такой процесс энергетически невыгоден и применяется только в лаб. условиях.

сит от кристаллографич. направлений (во всяком случае, до давлений в десятки кбар), причём вдоль направлений со слабым межмеханом взаимодействием она может в 8–10 раз превосходить С. по направлениям, вдоль к-рых в кристаллич. решётке более сильная связь; износные параметра решётки в этих направлениях в определ. интервале p может быть даже положительными (теллур, селен). С. — важнейшая характеристика вещества, к-рая позволяет судить о зависимости физ. свойств от межмеханом (межмолекулярных) расстояний. Знание С. газов (паров), жидкостей и твёрдых тел необходимо для расчёта работы тепловых машин, химико-технол. процессов, действия взрыва, аэро- и гидродинамич. эффектов, наблюдающихся при движении с большими скоростями, и т. д.

Лит.: В а р г а ф т и я Н. В., Справочник по теплотехническим свойствам газов и жидкостей, 2 изд., М., 1972; Таблицы физических величин. Справочник, под ред. И. К. Кикоина, М., 1976; см. также лит. при ст. Давление выское.

СИГМА-МОДЕЛИ (σ -модели) — модели теории поля, в к-рых m скалярных полей φ^i ($i = 1, \dots, m$) могут рассматриваться как задающие отображение $\varphi: R^d \rightarrow M$ d -мерного пространства-времени R^d (произвольной сигнатуры) в нек-рое многообразие M размерности m с метрикой $g_{ij}(\varphi)$, причём действие имеет вид:

$$S = \int_{\lambda^2} \frac{1}{\lambda^2} g_{ij}(\varphi) \partial_\mu \varphi^i \partial^\mu \varphi^j d^d x \quad (\mu=1, \dots, d). \quad (1)$$

Здесь λ — безразмерная константа связи, x — точка d -мерного пространства-времени, $\partial_\mu \equiv \partial/\partial x^\mu$, $\partial^\mu \equiv \partial/\partial x_\mu$ (по совпадающим верх. и ниж. индексам предполагается суммирование).

Исторически первая С.-м. возникла как эфф. теория безмассовых возмущений в следующей задаче. Рассмотрим теорию $(m+1)$ -компонентного поля n с дей-

$$S = \int \left\{ \frac{1}{\lambda^2} \partial_\mu \sigma_n \partial^\mu \sigma_n + V(\sigma^2) \right\} d^d x. \quad (2)$$

Если потенциал $V(\sigma^2)$ обладает минимумом при $\sigma^2 = 1$, то вблизи минимума имеются одно массовое поле, описывающее флуктуации модуля $|\sigma|$, и m безмассовых полей, описывающих флуктуации направления поля n с сохранением величины $\sigma^2 = 1$. Безмассовые поля допускают интерпретацию как координаты φ^i ($i = 1, \dots, m$) на сфере $\sigma^2 = 1$, и вклад полей φ^i в действие (2) дается φ -флор (1), где $g_{ij}(\varphi)$ — индуцируемая метрика на сфере. Первое приложение этой схемы было связано с теорией трёх псевдоскалярных π -мезонов, к-рые отождествлялись с полями φ^i в случае $m = 3$, а роль массового поля $|\sigma|$ играла т. н. σ -частица, к-рая и дала назв. модели. Дальнейшее развитие в этом направлении привело к *Скиржа модели*, эффективно описывающей низкоэнергетич. предел *квантовой хромодинамики* (КХД) и физико адронов.

С.-м. с действием (1) допускает два обобщения. Во-первых, вместо плоского d -мерного пространства-времени R^d можно рассматривать искривлённое. При этом в (1) появится метрика (гравитац. поле) $G_{\mu\nu}(x)$ и действие приобретёт вид:

$$S = \int \frac{1}{\lambda^2} g_{ij}(\varphi) \partial_\mu \varphi^i \partial^\mu \varphi^j G^{\mu\nu}(x) \sqrt{G} d^d x \quad (3)$$

($G = \det G^{\mu\nu}$). Имеет смысл также рассматривать пространство-время произвольной топологии. Такие теории лучше всего изучены в случае $d = 2$, они играют значит. роль в совр. теории струн (см. *Струн теория*). Для струнных приложений представляются также интерес С.-м., в к-рых M не являются многообразиями, а могут иметь разл. рода сингулярности, при этом действие должно быть доопределено в сингулярных точках. Во-вторых, при нек-рых значениях d (напр., $d = 1, 2$) можно рассматривать суперсимметричные (см. *Суперсимметрия*) С.-м., в к-рых x^μ заменяются на координаты x^μ, θ в *суперпространстве* (θ — чётная коорди-

ната), а поля $\varphi^i(x)$ — на суперполя $\Phi^i(x, \theta) = \varphi^i(x) + \theta \psi^i(x)$. Здесь ψ^i — фермионные компоненты суперполей, к-рые можно интерпретировать как касательные векторы к многообразию M .

Совр. интерес к С.-м. объясняется гл. обр. их прямой связью с геометрией. Геом. структуры на многообразии M проявляются в физ. свойствах соответствующих С.-м. Напр., если M — однородное многообразие, $M = G/H$, то С.-м. (1) может быть альтернативным образом описана как С.-м. на $M = G$, взаимодействующая с дополнит. *калибровочными полями*, отвечающим группе H . Это одно из обстоятельств, связывающих С.-м. с теориями *Инга* — *Миллса полей*. Другие яркие примеры проявления геометрии M в структуре С.-м. связаны с суперсимметричными С.-м. В случае $d = 2$ С.-м. обладает расширенной ($N = 2$)-суперсимметрией, если многообразие M калерово, и ($N = 4$)-суперсимметрией, если M гиперклерово (см. *Симметрическое многообразие*). В случае $d = 4$ суперсимметричные С.-м. существуют только на калеровых многообразиях, а для ($N = 2$)-суперсимметрии требуется гиперклерово многообразие. Несколькими иными ограничения на геометрию M возникает, если строить суперсимметричную С.-м., взаимодействующую с *супергравитацией* (т. е. суперобобщение действия (3)).

С.-м. являются удобным инструментом исследования общих свойств квантовой теории поля (КТП). Уже при $d = 1$ С.-м. позволяют исследовать проблему упорядочения операторов. В случае однородных многообразий или суперсимметричных С.-м. ставится и исследуется вопрос о совместности разл. способов упорядочения со свойствами симметрии теории. Мн. С.-м. при $d = 2$ оказываются очень похожими по своим свойствам на 4-мерные теории *Инга* — *Миллса*. В частности, имеются *асимптотическая свобода* и широкий спектр *непертурбативных явлений*, включая *спонтанное нарушение симметрии* и её восстановление, *инстантонные флуктуации* (см. *Инстантон*), образование конденсатов (в т. ч. фермионных пар в суперсимметричных С.-м.). Это позволяет оценивать применимость разл. непертурбативных методов, первоначально развитых для изучения явления *конфайнмента* в КХД (инстантонное исчисление, решётчатые и компьютерные вычисления и др.), на другом, значительно более простом примере двумерной теории.

Выше отмечалось, что С.-м. обычно возникают как эфф. теории безмассовых полей в более общих нелинейных теориях поля. В важных приложениях эти степени свободы отвечают коллективным возбуждениям и не входят в число первичных полей исходной теории. Чаще всего в С.-м. поля описывают квазичастицы, возникающие при спаривании фермионов. По существу таковы уюмивающиеся π -мезоны (составленные из кварка и антикварка, окружённых глюонным облаком). Др. важные примеры имеются в физике твёрдого тела (*квантовой Холла эффект*, модели *сверхпроводимости* и др.) и в теории элементарных частиц (*супергравитации* и др.).

С.-м., описывающие квазичастицы, чаще всего отличаются от моделей с действием (1) — (3) добавлением аномальных слагаемых, связанных с нетривиальностью гомотопич. групп $\pi_d(M)$ и $\pi_{d+1}(M)$ (см. *Топология*). В первом случае такие слагаемые в действии на т. о. пологически м, во втором — весс-зумин-новскими членами (J. Wess, B. Zumino, 1973). Первые изменяют непертурбативные свойства теории, вторые — проявляются в теории возмущений. Важный пример *топологического заряда* при $d = 2$ возникает уже в С.-м. на двумерной сфере, $M = S^2$, заданной условием $\sigma^2 = 1$:

$$\int n[\partial_\mu \sigma, \partial_\nu \sigma] \varepsilon^{\mu\nu} d^2 x \quad (4)$$

($\varepsilon^{\mu\nu}$ — антисимметрич. тензор, $\varepsilon^{12} = 1$). Выявление под интегралом (с учётом условия $\sigma^2 = 1$) является

полной производной, $\partial_x K^a$ (век-рото тока K^a) и интеграл $\int K^a dx^a$ определяет весс-зуминовский член в одномерной ($d=1$) С.-м. на $M = S^1$. Весс-зуминовский член при $d=2$ отвечает нетривиальной гомотопии, группе $\pi_2(M)$: в случае $M = S^2$ он связан с топологией характеристической отображения трёхмерной сферы в двумерную (известной в математике как инвариант Хопфа), а в случае $M = S^3$ — с топологическим зарядом, аналогичным (4).

При $d=2$ С.-м. является переформируемой КТП, несмотря на сильную нелинейность действия. При этом в зависимости от выбора многообразия M С.-м. в рамках теории возмущений может быть асимптотически свободной или иметь ренормализационное поведение, отвечающее нуль-зарядной ситуации (см. *Нуль-заряд*). Двумерная С.-м. имеет тождественно нулевую бета-функцию, если она обладает ($N=4$)-суперсимметрией. Этого же можно добиться введением весс-зуминовского или топологического члена с подходящим коэф. без обращения к суперсимметрии и гиперклареру многообразию.

Весс-зуминовские члены и топологич. заряды возникают в эффективных С.-м. как отражение аномалий исходных фермионных теорий. Важную роль в С.-м. играют также их собственные квантовые аномалии. Аномалиями могут быть d -мерная обскоординатная инвариантность в теории с действием (3), калибровочная N -симметрия в случае $M = G/H$, вейлевская симметрия $G_{\mu\nu} \rightarrow \rho^{(\alpha\beta)} G_{\mu\nu}$ (где $\varphi(x)$ — нек-рое вешественное поле), имеющаяся в теории с действием (3) при $d=2$.

Двумерные С.-м. с нулевой бета-функцией, являющиеся конформно-инвариантными (см. *Конформная инвариантность*), играют большую роль в теории струн, где они описывают всевозможные решения струнных уравнений движения. В настоящее время активно изучается вопрос о классификации всех конформно-инвариантных теорий и развиваются общие методы вычислений в конформных С.-м. Наиб. существ. продвижение в этом направлении достигнуто пока для более узкого класса ($N=2$)-суперконформных моделей при $d=2$, классификация к-рых близка к классификации осевинвариантных в *катастроф теория*.

Лучше всего изучены одномерные С.-м. На совр. этапе исследований осн. внимание уделяется развитию теории двумерных С.-м., как из-за их относит. простоты, так и из-за явной связи с теорией Янга — Миллса и теорией струн. Общая матем. теория таких С.-м. должна включать в себя теорию бесконечномерных и квантовых *Ли алгебр*, но она ещё не разработана. Единый подход к изучению многомерных ($d > 2$) С.-м. пока отсутствует.

Лит.: Gell-Mann M., Lévy M., The axial vector current in β -decay, «Nuovo Cim.», 1960, v. 16, p. 705; Witten E., Superstring theory and Morse theory, J. Diff. Geom., 1982, v. 17, p. 581; P e t e r s o n A., Chiral models: geometrical aspects, «Phys. Repts», 1987, v. 146, p. 136.

А. Ю. Морозов.

СИГНАЛ в т е о р и и л и ф о р м а ц и и — физ. процесс, значения параметров к-рого отображают передаваемое сообщение. С., с одной стороны, определяется

сообщением в С. осуществляется путём модуляции (рис.), обратный процесс, извлекающий сообщение из С., назв. демодуляцией.

Генератор носителя порождает процесс (назв. носителем), описываемый f -чей времени t :

$$f(t) = f(a, b, c, \dots, t).$$

Величины a, b, c, \dots представляют собой в отсутствие модуляции пост. параметры. В модуляторе эти инф-рмаци. параметры изменяются в зависимости от поступающего сообщения. Так, если сообщение — число, то приращение инф-рмаци. параметров ипродол. этому числу.

Если в качестве носителя выбрано гармонич. колебание, $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, то инф-рмаци. параметрами являются амплитуда A , частота ω и начальная фаза φ . Носитель $f(t)$, т. о., может быть подвергнут амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляции. АМ широко применяется в телефонии, ЧМ — в телевидении, ФМ — в системах телеуправления и радиосвязи.

Если носителем является последовательность импульсов определ. формы, напр. прямоугольной, то инф-рмаци. параметрами будут амплитуда, полярность, длительность, частота следования.

При передаче по каналу С. $S(t)$ взаимодействует с помехой $Z(t)$ — физ. процессом, вносящим дополнительные по сравнению с модуляцией изменения в значения его инф-рмаци. параметров.

Принятый сигнал $Y = \hat{V}(S, Z)$ отличается от $S(t)$, называемого полезным С., здесь \hat{V} — нек-рый оператор. В частном случае, когда оператор выражается в сумму, $Y = S + Z$, помеха назв. аддитивной. Возможны и более сложные случаи — мультипликативная помеха, *замыкая* сигнала и т. д. Развиты теория и методы фильтрации, обнаружения, выделения полезного С. на фоне помех.

А. Н. Ефимов.

СИЛА в м е х а н и к е — величина, являющаяся осн. мерой механ. действия на данное материальное тело др. тел. Это действие вызывает изменение скоростей точек тела или его деформацию и может иметь место как при непосредств. контакте (давление прижатых друг к другу тел, трение), так и через посредство создаваемых телами полей (поле тяготения, эл.-магн. поле). С. F — величина векторная и в каждый момент времени характеризуется численным значением, направлением в пространстве и точкой приложения. Сложение сил производится по правилу параллелограмма. Действующая С. может быть постоянной (С. тяжести), а может определ. образом зависеть от времени (перем. зл.-магн. поле), скорости (С. сопротивления среды) и положения в пространстве точки приложения С. (С. тяготения). Прямая, вдоль к-рой направлена С., назв. линией действия С. Если тело можно рассматривать как недеформируемое (абсолютно твёрдое), то С. можно считать приложенной в любой точке на линии её действия.

Измерение С. производят статич. или динамич. методами. Статич. метод основан на уравновешивании измеряемой С. другой, заранее известной. Динамич. метод основан на законе динамики $m\dot{w} = F$, позволяющем, если известна масса m тела и измерено ускорение w его свободного поступат. движения относительно *инерциальной системы отсчёта*, найти силу F .

Единицами измерения С. служат ньютон (Н) или дин (дин); 1 дин = 10^{-8} Н и 1 кгс $\approx 9,81$ Н.

С. М. Таро.

СИЛА ЗВУКА — см. *Интенсивность звука*.

СИЛА ИЗЛУЧЕНИЯ — то же, что *энергетическая сила света*.

СИЛА ИНЕРЦИИ — векторная величина, численно равная произведению массы m материальной точки на её ускорение w и направленная противоположно ускорению. При криволинейном движении С. и. можно разложить на касательную, или тангенциальную, состав-



фра. природой канала, по к-рому происходит его распространение (акустич., эл.-магн. и т. д.), с другой — параметрами, несущими сообщение, — и формами и значениями параметров С. Отображение

ляющую J_z , направленную противоположно масе, ускорению ω_z , и на нормальную, или центробежную, составляющую J_n , направленную вдоль г. нормали траектории от центра кривизны; число $J_z = m|\omega_z|$, $J_n = m\omega^2\rho$, где v — скорость точки, ρ — радиус кривизны траектории. При изучении движения по отношению к инерциальной системе отсчёта С. и. вводит для того, чтобы иметь формальную возможность составлять ур-ния динамики в форме более простых ур-ни статики (см. Д'Аламбера принцип, Кинематостатика).

Понятие о С. и. вводится также при изучении относительного движения. В этом случае, присоединив к действующим на материальную точку силам взаимодействия с др. телами переносную силу $J_{пер}$ и Корiolиса силу инерции, можно составить ур-ния движения этой точки в подвижной (внерциальной) системе отсчёта так же, как и в инерциальной. С. М. Торж.

СИЛА ОСЦИЛЛЯТОРА — безразмерная величина, через к-рую выражаются вероятности квантовых переходов в процессах излучения, поглощения и кулоновского возбуждения атомных, молекулярных или ядерных систем. С помощью С. о. находят вероятности спонтанного и вынужденного испускания и поглощения света, поляризуемости атомов, ширины уровней энергии и спектральных линий и др. важные характеристики систем. С. о. вводит для описания дипольных электрических и магнитных, а также электрнч. квадрупольных излучений [1—5]. В случае электронных переходов в атомах электрнч. дипольные С. о., как правило, порядка десятых долей единицы, а для магн. дипольных и электрнч. квадрупольных переходов — порядка 10^{-4} — 10^{-6} .

С. о. для электрнч. дипольного перехода между состояниями $|i\rangle$ и $|j\rangle$ с энергиями $\epsilon_i = \hbar\omega_i$ и $\epsilon_j = \hbar\omega_j$

$$F_{ji} = \frac{2m}{\hbar^2} (\omega_j - \omega_i) |\langle j | \hat{D}_z | i \rangle|^2,$$

где m и e — масса и заряд электрона, \hat{D}_z — оператор проекции дипольного момента. В атомной физике для переходов типа $|nl\rangle \rightarrow |n'l'\rangle$ (n и l — главное и орбитальное квантовые числа) вводят С. о. \bar{F}_{ji} , усреднённые по магн. квантовым числам начального $|i\rangle$ и конечного $|j\rangle$ состояний и не зависящие от направления поляризации. Анализ С. о. для атомных переходов позволяет установить важные закономерности, имеющие прикладное значение в физике газовых лазеров, плазмы и атмосферной, в астрофизике.

Для характеристики дифференциальных сечений возбуждения и ионизации атомов заряд. частицами вводят обобщённую С. о. $F_{ji}(k)$ [6, 7], к-рая в одночастичном приближении выражается через формфактор перехода:

$$F_{ji}(k) = \frac{2m}{\hbar k^2} (\omega_j - \omega_i) |\langle j | e^{ikr} | i \rangle|^2,$$

где $\hbar k$ — передаваемый в процессе рассеяния электрона импульс. Удобство понятия С. о. как характеристики квантовых переходов связано с наличием ряда теорем о суммировании. Для системы, состоящей из N электронов, справедливо правило сумм., сформулированное Х. Бете (H. Bethe) в 1930:

$$\sum_j F_{ji}(k) = N.$$

В соответствующем дипольном приближении имеет место правило сумм Томаса — Райхе — Кюна (W. Thomas, F. Reiche, W. Kühn, 1925), выполняющееся для произвольных атомов и молекул, во внеш. полях и без них, для любого направления поляризации, а также вне зависимости от того, являются ли разл. операторы угл. момента интегралами движения:

$$\sum_j F_{ji} = N.$$

Для оценки относ. вклада процессов испускания и поглощения в атомной физике выводится и др. частные правила сумм для средней С. о. $F_{пр}$.

Обычно С. о. находят экспериментально, измеряя времена жизни возбуждённых атомных или молекулярных состояний или интенсивностей испускания и поглощения. В измерениях 2-го типа используют источники излучения, для к-рых могут быть найдены или вычислены абс. или относит. значения населённости возбуждённых уровней. Эксперим. данные по относит. значениям дифференциальных сечений ионизации атомов электронным ударом сопоставляются с расчётами для обобщённых С. о., что позволяет апробировать теоретич. выбор волновых ф-ций и применимости первого, борновского приближения в теории столкновений.

Правила сумм Бете и Томаса — Райхе — Кюна являются частными случаями общей ф-лы суммирования для матричных элементов эрмитовых операторов \hat{A} :

$$\sum_i (\epsilon_i - \epsilon_j) |\langle i | \hat{A} | j \rangle|^2 = \frac{1}{2} \langle i | [\hat{A}, \hat{A}] | i \rangle,$$

где \hat{A} — гамилтониан системы, $|i\rangle$ и $|j\rangle$ — его собств. ф-ции с соответствующими значениями энергии ϵ_i и ϵ_j , $[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ — коммутатор операторов \hat{A} и \hat{B} . Выход за рамки этих частных случаев осуществляется, с одной стороны, уточнением теоретич. моделей изучаемых процессов, с другой — сопоставлением этих результатов с прецизионными экспериментами. Так, напр., исследуются релятивистские эффекты в тяжёлых атомах и межэлектронные корреляции. Многочастичные эффекты изучают вводя более чувствительные к корреляциям суммы С. о. с нелинейными энергетич. весом. Для молекулярных систем с анизотропным распределением плотности в нач. состоянии вводят правила сумм, описывающие тензорную связь мультипольных моментов.

В ядерной физике [8] поправки к обычным правилам сумм вводят из-за зависимости от скорости межкюлоновое взаимодействие и самосогласованного однопольного потенциала, из-за наличия статич. парного потенциала, а также ввиду возможного учёта барьонных возбуждений. Зависимость электрнч. моментов от изобарич. состояний приводит к зарядово-обменному вкладу в сумму С. о. В ядрах с избытком нейтронов асимметрично возбуждений, стимулированных разными компонентами изовекторных моментов, характерную правилу сумм С. о. с тензорной структурой в изотопич. пространстве (см. Изотопическая инвариантность). Суммы С. о. используются при исследовании колебаний формы сферич. ядер и относит. вкладов в коллективные возбуждения деформиров. ядер вращат. и вибрат. переходов. В проблеме ядерного дипольного резонанса при фотопоглощении С. о. связывают с зависимостью от скорости эфф. взаимодействия между частицами на орбитах вблизи уровня Ферми.

Лит.: 1) Бете Г., Солн и тер Э., Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами, пер. с англ., М., 1969; 2) Ельвешевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; 3) Собельман И. И., Введение в теорию атомных спектров, 2 изд., М., 1977; 4) Френкель С. Э., Оптические спектры атомов, М.—Л., 1963; 5) Фанон У., Куппер Дж., Спектральные распределения сил осцилляторов в атомах, пер. с англ., М., 1972; 6) Мотт Н., Мессер Г., Теория атомных столкновений, пер. с англ., [3 изд.] М., 1969; 7) Липовичи М., Inelastic collisions of fast charged particles with atoms and molecules — The Bethe theory revisited, [Rev. Mod. Phys., 1971, v. 43, № 3, p. 297; 1971, v. 43, № 4, p. 23; 8) Бор О., Моттельсон Б., Структура атомного ядра, т. 2 — Деформация ядер, пер. с англ., М., 1977.

Г. Л. Юхим.
СИЛА СВЕТА — одна из осн. световых величин, характеризующая сечение источника видимого излучения в нек-ром направлении. Равна отношению светового потока, распространяющегося от источника внутри элементарного телесного угла, содержащего данное

направление, к этому телесному углу. Единица С. с. в Междунар. системе единиц (СИ) — *кандела* (кд). Понятие С. с. применимо на расстояниях от источника, намного превышающих его размеры. Д. Н. Лаварев.

СИЛА ТОКА электрического — величина (I), характеризующая упорядоченное движение электрич. зарядов и численно равная кол-ву заряда ΔQ , протекающего через опред. поверхность ΔS в единицу времени: $I = \Delta Q / \Delta t \rightarrow dQ/dt$.

В гауссовой системе единиц С. т. имеет размерность $[I] = L^{3/2} M^{1/2} T^{-2}$ и измеряется в единицах СГС, к-рые иногда наз. с. т. а. м. п. е. р. а. м. В СИ единица С. т. является основной и носит назв. *ампер* ($1 \text{ А} \approx 3 \cdot 10^9 \text{ СГС}$).

Часто в качестве синонима С. т. говорят просто о токе или об электрич. токе, напр. ток в цепи или соотношение напряжения к току и т. п. Для уточнения распределения тока в пространстве вводят вектор *плотности электрического тока* $j(r, t)$, и тогда С. т., или суммарный ток, протекающий через площадку ΔS , определяется как поток вектора j через эту площадку $I = \int \Delta S \cdot j$. Следовательно, $j = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} (\Delta Q / \Delta S)$

(где n — нормаль к ΔS ; при этом I считается положительным, если в направлении n переносится положит. заряд). В т. н. линейных проводниках распределение j однородно по сечению и $I = j \Delta S$, где ΔS — нормальное сечение проводника. Плотность тока $j(r, t)$ и плотность электрич. заряда $\rho(r, t)$ составляют пространственную и временную компоненты единого 4-вектора плотности тока, 4-дивергенция к-рого равна нулю (т. е. этот 4-ток является чисто вихревым). В 3-мерном представлении это даёт ур-ние непрерывности

$$\nabla \cdot j + \partial \rho / \partial t = 0,$$

выражающее закон сохранения электрич. заряда. Его интегральная форма

$$I = \oint_S j dS = -\partial Q / \partial t = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

показывает, что ток, протекающий через замкнутую поверхность S , охватывающую объём V , равен изменению во времени суммарного заряда Q , сосредоточенного внутри V .

Измерения С. т. обычно осуществляются по его магн. действию. При этом различают истинно электрич. ток с плотностью j^e (ток проводимости, конвекционный и т. п.) и ток смешения с плотностью $j_{см} = (c/4\pi) \partial D / \partial t$ (D — вектор электрич. индукции). Иногда величину $j_{пол} = j^e + j_{см}$ называют полным током.

Лит.: Т я м и И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Д ж е к с о н Д. К., Классическая электродинамика, пер. с англ., М., 1985.

СИЛА ТЯЖЕСТИ — действующая на любую, находящуюся вблизи земной поверхности материальную частицу сила P , определяемая как геом. сумма действующей на ту же частицу силы притяжения Земли F и центробежной (перпеносной) силы инерции Q , вызывающей эффект суточного вращения Земли (рис.). Направление С. т. является направлением вертикали в данном пункте земной поверхности, а перпендикулярная к ней плоскость — горизонтальной плоскостью; углы λ и ϕ определяют соответственно геоцентрич. и астр. широты.

Величина $Q = m \omega^2 h$ (где m — масса частиц, h — её расстояние от земной оси, ω — угл. скорость вращения Земли) ввиду малости

ω^2 очень мала по сравнению с F . Поэтому С. т. мало отличается от силы притяжения Земли (разность между силами F и P имеет наиб. значение на экваторе — ок. 0,35% от силы F); разность между углами ϕ и λ также невелика и имеет наиб. значение (ок. 0,1°) при $\lambda = 45^\circ$.

При перемещении вдоль поверхности Земли от полюса к экватору С. т. несколько убывает вследствие возрастания величины Q и сферичности Земли и на экваторе примерно на 0,5% меньше, чем на полюсе. Под действием С. т. частица получает ускорение $g = P/m$, называемое ускорением и силой тяжести g и т. к-рое изменяется с широтой так же, как и С. т.

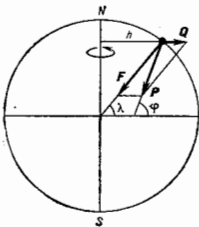
Во всех точках области, размеры к-рой малы по сравнению с радиусом Земли, С. т. можно считать численно равными и параллельными друг другу, т. е. образующими однородное силовое поле. В этом поле потенци. энергия частицы $\Pi = Pz$, где z — координата частицы, отсчитываемая по вертикали вверх от нек-рого нач. уровня; при перемещении частицы из положения, где $z = z_1$ в положение, где $z = z_2$, работа С. т. $A = -P(z_2 - z_1)$ и не зависит от вида траектории и закона движения частицы. Действие С. т. существенно влияет почти на все явления и процессы, происходящие на Земле, как в природе (включая живую), так и в технике. См. также *Гравиметрия*.

С. М. Тарс.
СИЛОВАЯ ОПТИКА — раздел оптики, в к-ром изучается воздействие на твёрдые среды интенсивных потоков оптич. излучения, в результате к-рого могут происходить структурные изменения и нарушаться механич. целостность этих сред. В оптотехнике под С. о. понимают оптич. устройства и системы, предназначенные для работы с интенсивными световыми потоками. С. о. развилась после появления лазеров в связи с использованием интенсивных световых потоков для оптич. обработки материалов, а также с необходимостью создания формирующих и передающих изображения оптич. систем, к-рые не теряют работоспособности при большой плотности энергии излучения.

В С. о. исследуют процессы выделения энергии в прозрачных (слабопоглощающих), неоглощающих и отражающих средах, подвергавшихся действию интенсивных световых потоков, результаты такого воздействия, а также определяют параметры излучения (плотность мощности, энергии, длительность), при к-рых происходит разрушение того или иного типа (оптич. пробой, плавление, испарение, растрескивание). При этом существ. значение могут иметь изменения оптич. характеристик вещества в процессе воздействия лазерного излучения (напр., коэф. отражения и показателя преломления, возникновения *самофокусировки света*, появления поглощения в продуктах световой эрозии вещества и др.). Определённые таким образом параметры излучения и режим его воздействия на вещество кладут в основу разработки лазерных установок для оптич. обработки материалов (сварка и резка, получение микроотверстий, изготовление элементов микроэлектроники и т. д.). Для характеристики работоспособности прозрачных оптич. материалов (стёкол, кристаллов, покрытий и т. д.) и диэлектрич. зеркал вводят по аналогии с механич. или электрич. прочностью понятие *лучевой прочности*. Данные о лучевой прочности материалов и изготавливаемых из них оптич. элементов используют при создании лазерных систем разд. назначения.

Лит.: Действие излучения большой мощности на металлы, под ред. А. М. Бонч-Бруевича и М. А. Ельшиевича, М., 1970; Ал е ш и И. В., И м а с Я. А., К о м о л о в В. Л., Оптич. прочность слабопоглощающих материалов, Л., 1974; Р э д и Д. Ж., Действие мощного лазерного излучения, пер. с англ., М., 1974.

А. М. Бонч-Бруевич.
СИЛОВАЯ ФУНКЦИЯ — функция координат силового поля, обладающая тем свойством, что элементарная работа сил поля равна полному дифференциалу этой функции. Силовое поле, для к-рого существует С. ф., наз. потенциальным.



СИЛОВОЕ ПОЛЕ — часть пространства (ограниченная или неограниченная), в каждой точке к-рой на помещенную туда материальную частицу действует определенная по численной величине и направлению сила, зависящая только от координат x, y, z этой точки. Такое С. п. наз. *стационарным*; если сила поля зависит и от времени, то С. п. наз. *нестационарным*; если сила во всех точках С. п. имеет одно и то же значение, т. е. не зависит ни от координат, ни от времени, С. п. наз. *однородным*.

Стационарное С. п. может быть задано ур-ниями

$$F_x = f_1(x, y, z), F_y = f_2(x, y, z), F_z = f_3(x, y, z), \quad (1)$$

где F_x, F_y, F_z — проекции силы поля F .

Если существует такая ф-ция $U(x, y, z)$, называемая силовой ф-цией, что элементарная работа сил поля равна полному дифференциалу этой ф-ции, то С. п. наз. *потенциальным*. В этом случае С. п. задается одной ф-цией $U(x, y, z)$, а сила F может быть определена через эту ф-цию равенствами:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}, \quad (2)$$

или $F = \text{grad } U$. Условие существования силовой ф-ции для данного С. п. состоит в том, что

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad (3)$$

или $\text{rot } F = 0$. При перемещении в потенциальном С. п. из точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ в точку $M_2(x_2, y_2, z_2)$ работа сил поля определяется равенством

$$A_{12} = U(x_2, y_2, z_2) - U(x_1, y_1, z_1)$$

и не зависит от вида траектории, по к-рой перемещается точка приложения силы.

Поверхности $U(x, y, z) = \text{const}$, на к-рых ф-ция сохраняется пост. значение, наз. *поверхностями уровня*. Сила в каждой точке поля направлена по нормали к проходящей через эту точку поверхности уровня; при перемещении вдоль поверхности уровня работа сил поля равна нулю.

Примеры потенциального С. п.: однородное поле тяжести, для к-рого $U = -mgy$, где m — масса движущейся в поле частицы, g — ускорение силы тяжести (ось z направлена вертикально вверх); вьютоново поле тяготения, для к-рого $U = km/r$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ — расстояние от центра притяжения, k — постоянный для данного поля коэффициент. Вместо силовой ф-ции в качестве характеристики потенциального С. п. можно ввести *потенциальную энергию* Π , связанную с U зависимостью $\Pi(x, y, z) = -U(x, y, z)$.

Изучение движения частицы в потенциальном С. п. (при отсутствии других сил) существенно упрощается, т. к. в этом случае имеет место закон сохранения механич. энергии, позволяющий установить прямую зависимость между скоростью частицы и её положением в С. п. С. М. Тор.

СИЛОВЫЕ ЛИНИИ — семейство кривых, характеризующих пространственное распределение векторного поля сил; направление вектора поля в каждой точке совпадает с касательной к С. л. Т. о., ур-ния С. л. произвольного векторного поля $A(x, y, z)$ записываются в виде:

$$\frac{dx}{A_x(x, y, z)} = \frac{dy}{A_y(x, y, z)} = \frac{dz}{A_z(x, y, z)}.$$

Плотность С. л. характеризует интенсивность (величину) силового поля. Область пространства, ограниченная С. л., пересекающими к.-л. замкнутую кривую, наз. *силовым трубкой*. С. л. вихревого поля замкнуты. С. л. потенциального поля начинаются на источниках поля и заканчиваются на его стоках (источники отдают. знака).

Понятие С. л. введено М. Фарадеем при исследовании магнетизма, а затем получило дальнейшее развитие в работах Дж. К. Максвелла по электромагнетизму. Согласно представлениям Фарадея и Максвелла, в пространстве, пронизываемом С. л. элетрич. и магн. поля, существует механч. напряжения, соответствующие патажению вдоль С. л. и давлению поперек них. Математически эта концепция выражена в *Максвелла теореме напряжений эл.-магн. поля*.

Наряду с использованием понятия С. л. чаще говорят просто о линиях поля: напряженности элетрич. поля E , индукции магн. поля B и т. п., не делая спец. акцента на отношении этих полей к силам.

СИЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА — *фокусировка частиц в ускорителе*, при к-рой частота бетатронных (поперечных) колебаний частицы больше частоты обращения. Примером С. ф. является *закономерная фокусировка*, фокусировка магн. полем со знакопеременным градиентом.

СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — одно из фундам. взаимодействий элементарных частиц, интенсивность к-рого, характеризуемая константой связи (*константой взаимодействия*), значительно больше, чем у др. типов взаимодействий — эл.-магн., слабого и гравитационного.

Вообще говоря, интенсивность взаимодействия зависит от характерных для процесса взаимодействия пространственных и временных масштабов, и выделение С. в. в особый класс имеет фактически более глубокие основания — оно обусловлено участием во взаимодействии специфич. физ. полей. Более того, взаимодействия, к-рые наблюдаются и рассматриваются как не зависящие друг от друга, могут оказаться разл. проявлениями более общего единого взаимодействия. Примером может служить объединение эл.-магн. и слабого взаимодействий в рамках теории *электрослабого взаимодействия*. Существуют также модели *великого объединения*, в к-рых делается попытка объединить сильное, эл.-магн. и слабое взаимодействия. Имеется надежда на объединение всех фундам. взаимодействий, включая гравитационное, в рамках единой суперсимметричной теории (см. *Суперсимметрия*).

До 1930-х гг. для описания наблюдаемых физ. явлений достаточно было рассматривать гравитац. и эл.-магн. взаимодействия. Первые играют решающую роль в явлениях космич. масштабов, а вторые ответственные за строение атомов, молекул и за всё многообразие внутр. свойств твердых тел, жидкостей и газов. Наличие С. в. проявилось, когда была открыта сложная структура атомных ядер, состоящих из протонов и нейтронов (нуклонов). Эксперимент показал, что взаимодействие между нуклонами гораздо сильнее электромагнитного, поскольку типичные энергии связи нуклонов в ядрах порядка неск. МэВ, в то время как энергии связи в атомах порядка неск. эВ. Кроме того, эти силы, в отличие от электромагнитных и гравитационных, обладают малым радиусом действия — 10^{-13} см. В квантовой теории радиус действия сил обратно пропорционален массе частиц, обмен к-рыми обуславливает взаимодействие. Поэтому К. Юкава (Н. Yukawa) в 1935 высказал предположение о существовании *тяжелых квантов* — *мезонов*, переносчиков С. в. В 1947 в *космических лучах* были открыты первые, наиб. лёгкие из таких частиц — π -мезоны.

Сильно взаимодействующие частицы получили назв. *адронов*. Их общее кол-во исчисляется спец. сотнями. Адроны разделяются на *барионы*, обладающие *барионным числом* (B), и мезоны, для к-рых $B = 0$. В природных условиях, в промышленных применениях и в ядерных лабораториях обычно имеют дело с барионами (протонами, нейтронами, и атомными ядрами) сравнительно небольших энергий, гораздо меньших, чем их масса (в системе единиц, в к-рой $c = 1$). Мезоны рождаются при столкновениях частиц, когда энергия столкновения достаточно велика (сотни МэВ и выше).

Обширную область физики, изучающую ядерные реакции при низких энергиях, а также свойства атомных ядер, обусловленные С. в., принято относить к *ядерной физике*. Физика С. в. в более узком смысле обычно имеет дело с элементарными частицами, участвующими в процессах соударения частиц достаточно высоких энергий (входящих в состав космич. лучей или созданных в лаб. условиях на ускорителях заряд. частиц). Энергия, выделяющаяся при соударении частиц может на два-три порядка превосходить массу протона. Лишь при достаточно высоких энергиях сталкивающихся частиц появляется возможность рождения новых тяжёлых частиц и можно получить более детальное представление о характере С. в., исследовать его свойства на очень малых расстояниях.

Все адроны, за исключением протона, нестабильны (нейтроны, входящие в состав стабильных атомных ядер, стабильны, хотя свободный нейтрон распадается за время $\sim 10^3$ с на протон, электрон и электронное антинейтрино). При этом большинство адронов обладает крайне малым временем жизни, характерным для С. в. [порядка $(10^{-22} - 10^{-24})$ с]; они наз. *резонансами*. Рождающиеся при соударениях частиц резонансы идентифицируются обычно по продуктам их распада. Для их изучения создана специализированная эксперим. техника (равн. *детекторы* частиц, *ионизационные калориметры*). Регистрации актов соударения производится с помощью ЭВМ, что позволяет проанализировать миллионы событий, удовлетворяющих тем или иным критериям отбора. Совр. установки для исследований в области физики высоких энергий (а первую очередь сами ускорители) представляют собой крупные и дорогостоящие сооружения, для к-рых характерно сочетание больших размеров и высокой точности, использование наиб. передовых технологий и разработок, таких, как сверхпроводящие магниты.

Взаимодействия адронов. За 40 лет, прошедших после открытия π -мезонов, открыты и изучены многочисленные семейства адронов и их взаимодействия. При сравнительно низких энергиях сталкивающихся частиц (порядка характерной энергии 1 ГэВ) наиб. важную роль в адронной физике играют резонансные взаимодействия. Их признаком являются более или менее ярко выраженные пики в сечении рассеяния, обусловленные одночастичными адронными состояниями. Иначе говоря, такой процесс взаимодействия состоит в образовании и последующем распаде нестабильного адрона. Ширина пика определяется обратным временем жизни промежуточного состояния. При повышении энергии всё большую роль начинают играть многочастичные промежуточные состояния и процессы рождения новых частиц, в первую очередь лёгчайших из них — π -мезонов. При энергиях соударения, большей в неск. ГэВ, определяющую роль играют процессы множеств. рождения адронов (см. *Множественные процессы*), а упругие и полные эфф. сечения взаимодействия становятся плавающим ф-циями энергии соударения. Наиб. энергоядущее в лаб. условиях $\sim 10^8$ ГэВ в системе центра масс (СЦМ) достигнуто при соударении встречных $p\bar{p}$ -пучков.

При энергиях в десятки ГэВ (в СЦМ) и выше наблюдается характерный для всех адронов медленный рост эфф. сечений взаимодействия. Осн. часть процессов (ок. 80%) составляют при этом неупругие взаимодействия с рождением десятков вторичных частиц. Ввиду большого числа степеней свободы, эффективно участвующих в процессе соударения, проявляются статистич. свойства родившихся адронов и с успехом может быть использовано термодинамич. и гидродинамич. описание отд. этапов процесса множеств. рождения.

При достигнутых энергиях большая часть неупругих процессов происходит в результате т. н. микгких соударений (см. *Мягкие процессы*), для к-рых характерны небольшие (неск. сотен МэВ) передачи импульса в поперечном направлении. Исвое понимание меха-

низма таких процессов отсутствует, хотя имеются феноменологич. модели, систематизирующие и описывающие многочисл. эксперим. данные по угл. и энергетич. распределением вторичных частиц. Как одну из характерных особенностей нуклонных распределений (см. *Импульсный процесс*) для больших продольных импульсов вторичной частицы можно отметить зависимость только от отношения продольного импульса к его максимально возможному значению (с к е й л и н г Ф е й н м а в а).

Заметную долю неупругих процессов составляют также «катастрофы» (жесткие соударения с большой передачей импульса, к-рые приводят к образованию более или менее резко выраженных струй вторичных адронов (группы на нек. адронов, испущенных в узкий конус углов; см. *Струя адронная*). С ростом энергии доля таких процессов нарастает, и в наиб. высокоэнергетич. $p\bar{p}$ -соударениях они составляют до 20% всех событий, в значит. мере определяя рост полных сечений взаимодействия. Осн. черты таких процессов описываются на основе представления о *партонах* — слабо связанных друг с другом составных элементах адронов. Считается, что при жестком соударении происходит рассеяние на большой угол двух или большего числа партонов, входящих в состав двух сталкивающихся адронов с последующим переходом партонов и адронные струи. Такие процессы находят своё объяснение в *квантовой хромодинамике* (КХД).

Упругое рассеяние адронов при высоких энергиях составляет ок. 20% событий и тесно связано с неупругими процессами. Оно имеет в осн. дифракционный, или теневой, характер: выбывание частиц из падающего на мишень пучка, происходящее за счёт неупругих процессов, ведёт к упругому рассеянию, что аналогично дифракции света при наличии поглощающего объекта. Такому механизму соответствует малость действия части амплитуды упругого рассеяния в области дифракц. пика (при малых передаваемых импульсах) по сравнению с её мнимой частью (см. *Дифракционное рассеяние*). Кроме того, заметную долю событий составляют своеобразные процессы *дифракционной диссоциации*, при к-рых дифракционно рассеивающийся адрон переходит в возбуждённое состояние, распадающееся затем на вторичные частицы.

В эксперименте наблюдается сужение дифракц. пика в дифференциальном сечении упругого рассеяния по мере роста энергии, что означает рост эфф. радиуса взаимодействия адронов с увеличением энергии. Такое поведение характерно для теории полюсов Редже (см. *Редже полюсов метод*), согласно к-рой асимптотич. поведение амплитуды процесса С. в., рассматриваемой как *аналитическая функция* своих аргументов, определяется крайней правой особенностью в комплексной плоскости угл. момента J . Если эта особенность в комплексной J -плоскости является полюсом, то процесс взаимодействия можно рассматривать как результат обмена *реджеоном* — своеобразным адронным состоянием с переменными спином J и массой. В случае упругого рассеяния соответствующий реджеон, по-видимому, отсутствует и характер особенности в J -плоскости (т. е. особенность Померанчука), определяющий асимптотич. поведение амплитуды упругого рассеяния, до сих пор не выяснен.

С точки зрения метода полюсов Редже особый интерес представляют бинарные адронные процессы $a_1 + a_2 \rightarrow a_3 + a_4$, где адроны a_3, a_4 отличаются от a_1, a_2 . С ростом энергии сечение такого процесса и ширина пика в угл. распределении падают характерным образом, указывая на то, что при высоких энергиях в таких процессах происходит обмен реджеоном с определ. зависимостью спина J от массы m (траекторий полюса Редже). При целых значениях спина реджеон должен быть обычным адроном, а всё семейство таких адронов, обладающих одинаковыми внутр. квантовыми числами, должно лежать на одной траек-

тория Редже. Эксперим. данные по массам и спинам резонансов действительно говорят о существовании таких редже-семейств адронов. При этом траектории Редже, объединяющие адроны каждого семейства, оказываются практически прямыми линиями в переменных J, m^2 , имеющими одинаковые (примерно) наклоны.

Применение общих принципов теории. С. в., как и др. типы взаимодействий элементарных частиц, должны описываться *квантовой теорией поля* (КТП). Осн. препятствием для построения квантовополюсовых моделей в течение и. л. лет была большая величина эфф. константы связи адронов, не позволяющая использовать методов *возмущенной теории*, по существу — единственного хорошо разработанного аналитич. подхода в КТП. Поэтому большое развитие в теории С. в. получили методы, к-рые используют общие принципы теории для определения свойств *матрицы рассеяния*. К числу таких общих принципов относятся унитарность, релятивистская инвариантность, *перекрестная симметрия* (кроссинг-симметрия), *причинность* (см. *Причинности принцип*). В этом подходе осн. роль играет изучение аналитич. свойств матричных элементов, рассматриваемых как ф-ции комплексных переменных, к-рым служат кинематич. инварианты, такие, как квадрат энергии и квадрат передаваемого импульса.

Условие унитарности матрицы рассеяния, выражающее математически тот факт, что сумма вероятностей всех возможных конечных состояний процесса соударения равна единице, связывает характеристики упругого рассеяния и неупругих процессов. В частности, *мнимая часть амплитуды упругого рассеяния на нулевой угол* выражается через полное сечение рассеяния (*оптическая теорема*). Эта связь лежит в основе описания дифракц. рассеяния адронов при высоких энергиях, а также может быть использована для того, чтобы установить соотношения между амплитудами разл. бинарных процессов. Условие унитарности определяет характер особенностей амплитуд как аналитич. ф-ций комплексных переменных. На практике часто используется предположение, что матрица рассеяния имеет только те особенности, к-рые диктуются условием унитарности и соответствуют отд. адронам (полосам) или порогам рождения нек-р. частиц (точки ветвления).

Согласно кроссинг-симметрии, единая аналитич. ф-ция в разл. областях своих аргументов описывает как амплитуду процесса $a_1 + a_2 \rightarrow a_3 + a_4$, так и амплитуду процессов $a_1 + \bar{a}_2 \rightarrow \bar{a}_3 + a_4$, $a_1 + \bar{a}_2 \rightarrow \bar{a}_3 + a_4$ (где \bar{a}_i означает адрон, являющийся античастицей по отношению к a_i). Аналогичное утверждение (с заменой любой входящей частицы на выходящую античастицу и наоборот) применимо и при большем числе частиц. Совместное рассмотрение перекрестных процессов оказалось очень плодотворным в физике С. в. Оно тесно связано с методом полюсов Редже и в сочетании с ним приводит к полезным правилам сумм, связывающим интегральный низкоэнергетич. вклад амплитуды бинарного процесса с её высокоэнергетич. поведением, к-рое определяется подкасами Редже. Это в свою очередь приводит к концепции *дuality* (см. *дuality*), согласно к-рой описание амплитуды бинарного процесса с помощью резонансов прямого канала должно быть эквивалентно её описанию с помощью полюсов Редже перекрестного канала. Дуальная резонансная модель смыкается с теорией струн (см. *Струнные модели адронов*) и на качеств. уровне отражает осн. свойства адронных резонансов.

Существенные результаты даёт также использование принципа причинности, согласно к-рому к. л. событие может воздействовать лишь на события, связанные с ним *временеподобным интервалом* и происходящие и более поздние моменты времени. Требования причинности, выраженное в матем. форме, накладывает серьёзные ограничения на аналитич. свойства элементов матрицы рассеяния, что позволяет написать дисперсионные соотношения, связывающие действительные и мнимые части амплитуд разл. процессов.

Т. к. мнимые части амплитуд упругого рассеяния внедрённые выражаются через полные сечения, дисперсионные соотношения связывают наблюдаемые величины и могут использоваться при анализе эксперим. данных, позволяя, в частности, судить о поведении полных сечений при высоких энергиях (см. *Дисперсионные соотношения*).

Совместное использование общих принципов лежит в основе аксиоматич. подхода в теории С. в., конечной целью к-рого является описание всех адронных взаимодействий на основе системы исходных постулатов (см. *Аксиоматическая квантовая теория поля*). К числу осн. достижений такого подхода относится ряд высокоэнергетич. теорем (*асимптотические теоремы*). В частности, было показано, что полные сечения адронных взаимодействий не могут увеличиваться с ростом энергии ν быстрее, чем $\ln^2 \nu$ (т. е. ограничение Фруассара), а ширина дифракц. пика упругого рассеяния не может сужаться быстрее, чем $\ln^2 \nu$. При доп. правдоподобных предположениях было показано, что сечения взаимодействий частиц и соответствующих им античастиц с одной и той же мишенью при достаточно высоких энергиях должны сравниваться (*Померанцевская теорема*).

При более прагматич. подходе, типичном для совр. состояния теории, общие принципы или их следствия используются как составные элементы феноменологич. моделей С. в. и служат для анализа эксперим. данных. К ним можно отнести применение условия унитарности в моделях дифракц. рассеяния адронов, использование унитарности и дисперсионных соотношений при анализе низкоэнергетич. адронных взаимодействий и т. п.

Симметрия сильных взаимодействий. Характер С. в. в значит. мере определяется их свойствами симметрии. Под симметрией здесь понимается неизменность (инвариантность) состояния системы или закона её взаимодействия (точнее, инвариантность *delta*-матрицы системы) при тех или иных преобразованиях, к-рые, с точки зрения их матем. структуры, характеризуются *группой* преобразований. Если действие системы инвариантно относительно нек-рых преобразований, а состояние системы не инвариантно, то говорят о *спонтанном нарушении симметрии*. Значение симметрии состоит в том, что она накладывает жёсткие требования на форму взаимодействия и состав частиц. В частности, симметрия лежит в основе классификации адронов. Из всех типов взаимодействий С. в. обладает наиб. высоким уровнем симметрии. Часть симметрии является приближённой, причём нарушение симметрии в ряде случаев сравнительно невелико и характер этого нарушения поддается объяснению. С. в. (подобно электромагнитным) инварианты относительно *пространственной инверсии, обращения времени и зарядового сопряжения* (а также относительно преобразований Лоренца, вращений в пространстве, сдвигов в пространстве и времени). В соответствии с этим в С. в. сохраняются пространственная *чётность* и *зарядовая чётность*. Сохраняется также *барионное число*.

Из числа *внутренних симметрий* С. в. в спектре адронов наиб. ярко проявляется т. н. симметрия *ароматов*, к-рая математически описывается как группа унитарных унитарных преобразований $SU(n)$. Эта симметрия — приближённая. Её простейший частный случай — *изотопическая инвариантность*, соответствующая группе $SU(2)$, а более общий — т. е. унитарная симметрия, соответствующая группе $SU(3)$. Из-за наличия симметрии ароматов все адроны группируются в мультиплеты — наборы частиц с одинаковыми спинами и чётностями и близкими массами, реализующие линейные представления соответствующей группы симметрии. Это изотонич. мультиплеты, характеризующиеся определ. значением *изотопического спина* (такие, как дублет π или триплет π^+, π^0, π^-), более общие унитарные мультиплеты группы $SU(3)$ (напр., октет

нуклонов в *гилеронов* или октет псевдоскалярных π -, K -, η -мезонов) и т. д. (см. *Элементарные частицы*). Кроме того, наличие симметрии ароматов требует, чтобы *лагранжиан эффективный* взаимодействия адронов был инвариантен группы $SU(n)$, что и значит, мере определяет его форму.

Существование симметрии ароматов и наличие адронных мультиплетов объясняется тем, что адроны составлены из *кварков* неск. видов: u, d, s, c, b и $\bar{c}, \bar{b}, \bar{s}, \bar{d}, \bar{u}$. Каждый вид кварков характеризуется массой и ароматом — квантовым числом, сохраняющимся в $S. v.$ В пределе точной симметрии массы адронов, входящих в один мультиплет, должны совпадать. Нарушение симметрии объясняется различием масс кварков разл. ароматов ($m_u < m_d < m_s < m_c < m_b$). Это нарушение сравнительно невелико, если разности масс кварков малы по сравнению с масштабом энергий, характерных для $S. v.$, по порядку величины равных $(0,2-1,0)\text{ГэВ}$ [что соответствует характерным расстояниям $r = (0,2-1,0) \cdot 10^{-13}$ см]. Такое условие лучше всего выполняется для наиб. лёгких u, d -кварков, и поэтому изотония инвариантность, обусловленная u, d -симметрией, нарушена в наим. степени. Она реализуется с точностью в неск. процентов, так что поправки к ней находятся на уровне ожидаемых эл.-магн. поправок. При наличии более тяжёлого s -кварка нарушение адронной симметрии более существенно (на уровне десятков процентов), но всё же $SU(3)$ -симметрия (симметрия между u, d, s -кварками) очень полезна. Более высокие симметрии сильно нарушены из-за больших масс c, b -кварков.

Сущест. роль в $S. v.$ играет также *киральная симметрия*, характерная, вообще говоря, для безмассовых фермионов и обусловленная тем, что в пределе нулевой массы можно независимо преобразовывать левые (L) и правые (R) кварки, т. е. состояния со спином, направленным по импульсу и против него. Киральная симметрия отвечает группе $SU(n)_L \times SU(n)_R$. Она может проявиться в $S. v.$ в той мере, в какой массы кварков, входящие в исходный лагранжиан теории (т. е. токовые массы), малы по сравнению с характерной энергетич. шкалой $S. v.$ Лёгкие кварки u, d и в значит. мере s -кварк удовлетворяют этому условию. Однако, согласно совр. представлениям, киральная симметрия $S. v.$ спонтанно нарушена (помимо её явного нарушения массами кварков). Поэтому не наблюдаются мультиплеты, к-рые состояли бы из близких по массе адронов и являлись бы линейными представлениями группы $SU(n)_L \times SU(n)_R$, объединяя в один мультиплет адроны с разл. чётностью. Вместо этого должны появляться *голдстоуновские бозоны*. Их роль играют здесь псевдоскалярные мезоны, т. е. λ -мезоны группы $SU(2)$ и с меньшей точностью π, K, η -мезоны группы $SU(3)$. Массы этих мезонов обусловлены лишь малыми токовыми массами кварков, т. е. явным нарушением киральной симметрии. Это объясняет, почему псевдоскалярные мезоны (в первую очередь λ -мезоны) значительно легче др. адронов.

Низкоэнергетич. взаимодействия псевдоскалярных мезонов можно описать с помощью эфф. кирально-инвариантного (с точностью до массовых поправок) лагранжиана. Псевдоскалярные поля, входящие в этот лагранжиан, преобразуются при киральных преобразованиях нелинейным образом. Особое положение занимает при этом синглетный псевдоскалярный η' -мезон, масса к-рого велика и к-рый даже приближённо нельзя считать голдстоуновским бозоном. Его характеристики обусловлены аксиальной аномалией и структурой физ. вакуума.

Форма низкоэнергетич. мезонного лагранжиана диктуется киральной симметрией и характером её нарушения. При учёте соотношения *алгебры токов* и аксиаль-

ного тока *частичного сохранения* такой лагранжиан позволяет вычислить длины рассеяния псевдоскалярных мезонов и характеристики их распад. Барьоны при этом выступают как *солитоны* (см. *Скирма модель*).

В жёстких процессах, обусловленных $S. v.$ на малых расстояниях, проявляется также приближённая масштабная симметрия (скейлинг), т. е. инвариантность относительно растяжения координат (или импульсов) — m а с т а б и я и н в а р и а н т н о с т ь. Эта симметрия также спонтанно нарушена. Более ясное понимание механизма спонтанного нарушения киральной и масштабной симметрий достигается в КХД.

Квантовая хромодинамика как теория сильного взаимодействия. С 1970-х гг. в физике утвердился новый микроскопич. теория $S. v.$ — КХД. Согласно этой теории, $S. v.$ к-рое, в частности, удерживает кварки в адронах, обусловлено наличием у кварков специфич. цветовых степеней свободы (дополнительно к ароматам). Каждый кварк может находиться при этом в трёх физических эквивалентных цветовых состояниях, или, как говорят, имеет три цвета. Антикварки обладают тремя «дополнительными» цветами («антицветом»). $S. v.$ реализуется в цветовом пространстве и не различает ароматов (в то время как эл.-магн. и слабые взаимодействия определяют лишь ароматы кварков безотносительно к их цвету). Взаимодействие кварков осуществляется посредством восьми безмассовых векторных (глюонных) полей, слабые возбуждения к-рых (отдельные их кванты) наз. *глюонами*. При этом в свободном состоянии наблюдаются только бесцветные адроны, в к-рых цвета составляющих их кварков и антикварков скомпенсированы.

В основу КХД положен принцип локальной цветовой симметрии, к-рый утверждает, что можно независимо изменить цветовые состояния отд. кварков. Это возможно, разумеется, лишь при наличии глюонного поля, способного принять на себя избыточный цвет. Эквивалентность разл. цветовых состояний формулируется математически как инвариантность (точн а я) относительно преобразований цветовой группы $SU(3)$, причём параметры групповых преобразований могут зависеть от точек пространства-времени. Такие теории наз. к а л и б р о в о ч н ы м и. Принцип локальной калибровочной инвариантности позволяет однозначно фиксировать лагранжиан хромодинамики, к-рый подобен электродинамич. лагранжиану, но учитывает цветовые степени свободы. В результате напряжённости глюонного поля отличаются от напряжённости электр. и магн. полей электродинамики дополнительными нелинейными по калибровочному полю членами. Наличие нелинейных членов, необходимых для калибровочной инвариантности КХД, приводит к самодействию глюонов. Др. словами, глюоны обладают цветовой ми з а р я д а м и (в отличие от фотонов, не обладающих зарядом, зарядами). Это, в свою очередь, приводит к наиб. важному свойству КХД — эффекту а н т и к р а н и р о в к и заряда, к-рый означает, что *эффективный заряд* кварков и глюонов велик на больших расстояниях и становится малым при уменьшении расстояний. Вследствие этого свойства $S. v.$ на малых и больших масштабах оказываются совершенно различными. На малых расстояниях или при больших передаваемых импульсах (больше $(2-3)\text{ГэВ}$) эфф. цветовой заряд стремится к нулю. Это свойство получило назв. *асимптотической свободы*. Кварки и глюоны на малых расстояниях ведут себя как почти свободные частицы, и все процессы с их участием можно рассчитывать по теории возмущений, непосредственно используя исходный лагранжиан КХД. Массы кварков u, d, s при этом малы (токовые массы: $m_u \approx 4$ МэВ, $m_d \approx 7,5$ МэВ, $m_s \approx 150$ МэВ), так что в первом приближении ими можно пренебречь. Из-за малости масс и слабости взаимодействия на малых расстояниях имеют место приближённые киральная и масштабная симметрии.

Такой подход позволяет успешно описывать обширный класс процессов физики высоких энергий — жёсткие процессы. Классич. пример жёстких процессов — *глубоко неупругий процесс рассеяния лептонов* (электрон, мюон, нейтрино) на нуклонах, изучение к-рого привело к представлению о партонах (почти свободных кварках и глюонах внутри нуклона) и стимулировало создание КХД. Глубоко неупругое рассеяние трактуется как результат упругого рассеяния лептона на одном из кварков нуклона. Измерение импульса рассеянных лептонов в таких процессах позволяет экспериментально найти ф-ции распределения кварков и глюонов по доле переносимого ими импульса в быстро движущемся нуклоне (т. н. *структурные функции*). Оказалось, напр., что при передаваемых импульсах порядка неск. ГэВ (т. е. при исследованиях структуры кварков на расстояниях порядка 10^{-14} см) примерно половина импульса переносится глюонами. Учёт хромодинамик. поправки приводит к медленному изменению партонных распределений при изменении пробного импульса Q (нарушение т. н. *скейлинга* Б. В. Фейнмана; см. *Масштабная инвариантность*). При увеличении Q можно проникнуть глубже внутри кварка и должно наблюдаться увеличение числа кварк-антикварковых пар и глюонов, составляющих его поляризацию, облако, с одноврем. уменьшением переносимого каждым партонном доли импульса. Эксперим. данные по варушению скейлинга в глубоко неупругих процессах в целом неплохо согласуются с предсказаниями расчётов.

Аналогично жёсткие адронные процессы с образованием струй можно истолковывать как результат упругого рассеяния содержащихся в адронах кварков и глюонов с последующим их переходом в адроны. Особую проблему представляет при этом вопрос о механизме образования бесцветных адронов, входящих в состав струй. Обычно считается, что при рассеянии кварка по мере его удаления от точки столкновения между ним кварком и остающейся частью адрона возникает струнная конфигурация глюонного поля, к-рая затем разрывается с образованием «обесцвечивающей» кварк-антикварковой пары (фактически — большого числа таких пар), так что в результате возникает бесцветные мезоны, составляющие адронные струи. Полный расчёт подобных процессов в рамках КХД невыполним из-за того, что образование адронов происходит на больших расстояниях, где взаимодействие кварков и глюонов становится сильным. Поэтому убедительное доказательство в пользу существования опасного механизма отсутствует. В качестве при обработке эксперим. данных используют упрощённые модели образования и разрыва струн.

Важную роль в КХД играет спонтанное нарушение симметрии. Из-за усиления взаимодействия на больших расстояниях нарушается присущая лагранжиану КХД приближённая масштабная инвариантность. При этом возникает характерная шкала Λ . ~ 200 МэВ (соответствующая расстояниям $\sim 10^{-13}$ см), о наличии к-рой свидетельствует появление ненулевого вакуумного среднего от следа тензора энергии-импульса глюонного поля. Др. словами, вакуум КХД (т. е. осн. состояние системы сильно взаимодействующих q - \bar{q}) населён флуктуирующими глюонными полями и имеет ненулевую (отрицательную) плотность энергии ϵ и избыточное давление p по сравнению с «наивным» вакуумом теории возмущений. Согласно существующим оценкам, $\epsilon = -p \approx -0,5$ ГэВ/ $(10^{-13}$ см) 3 . Характер вакуумных флуктуаций остаётся не вполне ясным; возможно, что существ. роль здесь играют *инстантоны*. Спонтанно нарушается также присущая лагранжиану КХД приближённая киральная симметрия, о чём свидетельствует появление ненулевых вакуумных средних от скалярных комбинаций, составленных из кварковых полей (кварковых *вакуумных конденсатов*). Др. словами, вакуум КХД населён также кварк-антикварковыми парами, дающими

дополнит. отрицат. вклад в плотность энергии. Считается, что вследствие спонтанного нарушения симметрии кварки-квантичики, входящие в состав типичных адронов, приобретают значит. эфф. массу порядка 300 — 350 МэВ (т. н. конститутивные кварки). Последоват. теория спонтанного нарушения симметрии в рамках КХД пока не разработана.

Фигурирующие в КХД асимптотически свободная (на малых расстояниях) и удерживающая (на больших расстояниях) фазы кварк-глюонной материи должны проявляться не только тогда, когда последует отклик системы на малых и больших масштабах, но и как её возможные макроскопич. состояния: предполагается, что при достаточно большой плотности барьонов или при достаточно высокой темп-ре происходит образование *кварк-глюонной плазмы*, в к-рой кварки и глюоны взаимодействуют сравнительно слабо (так что вычисления можно проводить по теории возмущений). Ожидается, что, необходимая для этого плотность энергии всего в неск. раз превышает ядерную плотность, что примерно соответствует плотности энергии внутри типичного адрона. Помимо ранней Вселенной в первые 10^{-4} — 10^{-5} с её эволюции (см. *Космология*) и, возможно, внутр. части *нейтронных звёзд* новое состояние материи могло бы образоваться при соударении тяжёлых ультрарелятивистских ионов. Ведутся соответствующие эксперименты с целью получения и идентификации кварк-глюонной плазмы в лаб. условиях.

Имеются все основания считать, что качеств. физ. элементы микроскопич. теории S в. установлены. Теория взаимодействий на малых расстояниях хорошо разработана. Что же касается S в. на больших расстояниях, то их количеств. теория пока не создана. Это относится, в частности, к механизму удержания кварков в адронах. Определ. надежды возлагаются здесь на прямые численные расчёты с помощью ЭВМ, в к-рых 4-мерный континуум пространства-времени заменяется набором точек дискретной решётки и непосредственно вычисляются квантовые средние наблюдаемых физ. величин (см. *Решёточный метод* в КТП).

Лит.: Иден Р., Соударение элементарных частиц при высоких энергиях, пер. с англ., М., 1970; Тони в физике адронов, пер. с англ., М., 1976; Акиев Р. В., Хромодинамика и жёсткие процессы при высоких энергиях, М., 1981; Окунь Л. Б., Физика элементарных частиц, 2 изд., М., 1988; Индурайн Ф., Квантовая хромодинамика, пер. с англ., М., 1988. И. В. Аброев.

СИЛЬНОЛЕГИРОВАННЫЙ ПОЛУПРОВОДНИК — кристаллич. полупроводник, в к-ром примесные атомы (ионы) хаотически распределены в решётке, а их концентрация N превышает вековую критич. концентрацию $N_{кр}$. S п. представляет собой *неупорядоченную систему* примесей внутри упорядоченной монокристаллич. полупроводниковой матрицы.

При слабом легировании (см. *Легирование полупроводников*) примесные атомы можно считать изолированными друг от друга. Волновые ф-ции электронов и силовые поля U соседних примесных атомов (кулоновские для заряж. примесей — ионы, уругие — для нейтральных атомов) не перекрываются (рис. 1, а).

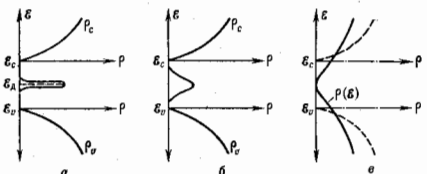


Рис. 1. Зависимость плотности примесных состояний ρ от их энергии ϵ для слаболегированного полупроводника (а); при среднем уровне легирования (б); при сильном легировании (в).

Количественно условие слабого легирования выполняется при соблюдении неравенств:

$$r \gg a_B, \quad (1)$$

$$r \gg r_0. \quad (2)$$

Здесь $r = N^{-1/3}$ — ср. расстояние между соседними примесными атомами, a_B — борковский радиус примесного атома в кристалле, r_0 — радиус экранирования кулоновского потенциала примесного иона электр. полем противоположно заряженных свободных носителей заряда. Неравенство (1) определяет отсутствие перекрытия волновых ф-ций электронов, неравенство (2) — силовых полей соседних атомов примеси:

$$U = (e^2/\epsilon r) \exp(-r/r_0). \quad (3)$$

Здесь ϵ — диэлектрич. проницаемость кристалла. Величина r_0 зависит от концентрации свободных носителей заряда n_0 , т. е. от концентрации примесей N . Для случаев невырожденного и полностью вырожденного газа носителей заряда соответственно

$$r_0 = (ekT/4\pi n_0 e^2)^{1/2}, \quad (4)$$

$$r_0 = 2^{-1}(\pi/3)^{1/3} (e\hbar^2 n_0^{-1/3} / m^* e^2)^{1/2}, \quad (5)$$

где m^* — эфф. масса носителя заряда.

С увеличением концентрации примесей N условия (1) и (2) нарушаются. Сначала перестает выполняться неравенство (2), т. к. по мере увеличения N примесные атомы сближаются и электрон, локализованный в потенциальной яме U у одного из них, начинает испытывать воздействие со стороны соседних атомов. При этом энергетич. уровень примесного электрона несколько смещается, но примесные уровни остаются дискретными. Смещение уровней зависит от взаимного расположения примесных атомов. Хаотичность последнего приводит к разбросу примесных уровней относительно дна зоны проводимости ϵ_c и потолка валентной ϵ_v в разных частях кристалла. Это проявляется в уширении примесного уровня, наз. классическим (рис. 1,б).

При дальнейшем увеличении N нарушается неравенство (1). Из-за перекрытия волновых ф-ций электронов соседних атомов дискретные уровни уширяются настолько, что преобразуются в пр им е с н ы ю з о н у. Пока в полупроводнике сохраняются уширенные примесные уровни либо обособленная от ϵ_c и ϵ_v примесная зона, уровень легирования относит к с р е д н е м у (или промежуточному). При достаточной большой концентрации примесей полностью нарушаются оба неравенства. Примесная зона продолжает расширяться, и при нек-рой критич. концентрации $N_{кр}$ она сливается как с зоной проводимости, так и с валентной зоной (рис. 1,в). Плотность состояний оказывается отличной от 0 практически во всей запрещенной зоне полупроводника («хвосты» плотности состояний). При этом газ носителей заряда уже не подчиняется статистике Больцмана; он становится вырожденным и подчиняется статистике Ферми.

При сильном легировании электроны взаимодействуют одновременно с некск. примесными атомами, ко-во и координаты к-рых из-за хаотич. распределения различны в разных частях кристалла. В результате потенц. энергия U примесных электронов приобретает случайный характер, приводящий к гоморфированию зон (рис. 2). «Хвосты» плотности состояний и их флуктуация. характер проявляются в электропроводности (см. *Пружкова проводимость, Протекающая теория*), в фотопроводимости (гигантское увеличение времени жизни носителей заряда), в электролюминесценции $p-n$ -переходов и гетеропереходов и др.

При $N > N_{кр}$ нарушается концентрационно-примесное равновесие, т. е. возникает отклонение от равенства $n_0 = N$. Это обусловлено образованием примесных кла-

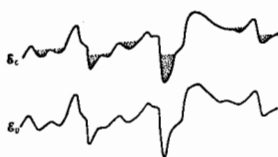


Рис. 2. Энергия носителей заряда в поле примесей при сильном легировании полупроводника.

стеров (комплексов). Комплексообразование может приводить к изменению концентрации носителей и положения примесных уровней примеси в запрещенной зоне. Зависимость $n_0(N)$ (рис. 3) при этом имеет вид:

$$N = n_0 + K(T)n_0^{m-q} (m n_0 - q N)^m / (m - q)^{m-1}, \quad (6)$$

где $K(T)$ — константа взаимодействия примесных атомов, m — число легируемых примесных атомов в кластере, q — электр. заряд кластера. При малых N

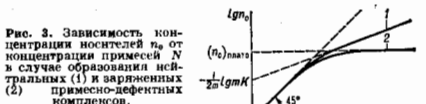


Рис. 3. Зависимость концентрации носителей n_0 от концентрации примесей N в случае образования нейтральных (1) и заряженных (2) примесно-дефектных комплексов.

зависимости (6) переходит в $n_0 = N$; при больших N и нейтральных кластерах

$$N = n_0 + m K(T)n_0^{2m}. \quad (7)$$

Для отрицат. кластера с $m = 1$ (взаимодействие атома примеси с к.-л. иным точечным дефектом) кривая (6) в области сильного легирования выходит на плато:

$$(n_0)_{\text{плато}} = \frac{-1+q}{\sqrt{1/|q|K(T)}}, \quad (8)$$

переходящее при $q = -1$ в соотношение

$$(n_0)_{\text{плато}} = \sqrt{1/K(T)}. \quad (9)$$

Заряд q может быть только отрицательным, ибо при $q = +1$ кластеры не уменьшаются, а при $q > +1$ даже должны увеличивать n_0 сверх введенной концентрации примесей N , что невозможно. Комплексообразование оказывает заметное влияние на процессы рассеяния и захвата носителей заряда, оптич., механич. и др. свойства. Основанное на комплексообразовании формирование сложных примесно-дефектных центров, обладающих отличными от атомов легирующей примеси энергетич. и рекомбинац. характеристиками, используются в практике легирования для придания материалу новых свойств.

Лит.: Фистуль В. И., Сильно легированные полупроводники, М., 1967; Фистуль В. И., Гринштейн П. М., Рытова Н. С., О полупроводниках легированных примесей в полупроводниках, «ФТД», 1970, т. 4, с. 84; Fair R. B., Weber G. R., Effect of complex formation on diffusion of arsenic in silicon, *ibid.*, Appl. Phys., 1973, v. 44, p. 273; Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г., Физика полупроводников, М., 1977; Пильковский Б. И., Фролов А. Л., Электронные свойства легированных полупроводников, М., 1979.

СИЛЬНОТОЧНЫЕ ПУЧКИ — пучки заряд. частиц, в к-рых собственные поля оказывают определяющее воздействие на динамику пучка. Характерные масштабы тока С. п. равен $I_0 F(\gamma)$, где $I_0 = mc^2/e \approx 17$ кА (для электронов), m — масса, e — заряд электрона, $F(\gamma) =$

растущая ф-ция полной энергии частиц γ (в единицах mc^2), зависящая от конкретной геометрии пучка. Существ. превышение тока над I_0 может быть достигнуто лишь при скоростях частиц, близких к c , или при компрессии объёмного заряда пучка неподвижными ионами. По переносимой мощности С. п. достигает $\sim 40^{13}$ Вт, за заданной энергии — 10^8 Дж, по энергии частиц ≥ 10 МэВ. Применяются как эноверонитель в схемах с быстрой кумуляцией энергии (инерциальный УТС; см. *Инерциальное удержание плазмы*), в приборах сильноточной электроники, для коллективного ускорения частиц (см. *Коллективные методы ускорения*) и т. д. Генерируются в *сильноточных ускорителях* в диапазоне длительной импульсы от 10 нс до 10 мкс.

Непосредств. источником электронного С. п. обычно является высоковольтный диод, работающий в режиме ограничения тока пространственным зарядом. Длительность импульса определяется временем перекрытия диодного промежутка приэлектродной плазмой. Плотность однородного тока эмиссия в плоском зазоре шириной d дается законом «трёх вторых», $j \approx \approx 5 \cdot 10^{-4} j_0 (\gamma_0 - 1)^{3/2} d^{-3}$, где $(\gamma_0 - 1)$ — анодное напряжение (в единицах mc^2/e). При повышении анодного напряжения сверх значения $\gamma_0 - 1 \approx d/R$, где R — радиус катода, одномерность нарушается и диод переходит в режим сильного сжатия потока соств. магн. полем пучка (см. *Пилч-эффект*). Эффективно эмитирует тогда только кольцевая периферия, часть, а С. п. собирается на аноде вблизи оси в области с размером $\sim d$. На осн. части диода линии тока С. п. лежат на искажённых пространственным зарядом эквипотенц. поверхностях, поэтому такой поток получил назв. паранотенциального. Макс. ток С. п. в паранотенц. режиме равен $(I_0 R / 2d) (\gamma_0 - 1) \operatorname{arctg} \gamma_0$.

Для вывода С. п. из диода либо используется прозрачный для электронов фольговый анод, либо коаксиальный диод помещается в продольное магн. поле. Электронный паранотенц. поток трубчатой конфигурации движется в коаксиальном диоде вдоль цилиндрич. эквипотенц. поверхностей и не пересекает зазор в радиальном направлении (т. н. магн. изоляция). Достаточный для изоляции магн. поток через диод равен $(mc^2/e) (\gamma_0 - 1)^{3/2}$. Ток, отдаваемый коаксиальным диодом с магн. изоляцией, определяется пропускной способностью канала транспортнотрива, а длительность импульса — временем перекрытия зазора приэлектродной плазмой поперёк надирующего магн. поля. Напущные результаты по длительности и устойчивости работы диода получены в неоднородном сходящемся магн. поле.

Распространение С. п. в вакууме возможно в продольном магн. поле, заметно превышающем $(mc^2/ea) (\gamma_0 - 1)^{3/2}$, где a — радиус С. п., но даже в бесконечно большом поле ток не может превышать величину $I_0 (\gamma_0^{3/2} - 1)^{3/2} 2 \ln(b/a)$, где b — радиус камеры дрейфа. Ограничение обусловлено повышением электростатич. потенциала в объёме пучка за счёт его пространственного заряда и слабее всего сказывается в случае трубчатого пучка. Приведённая энергия частиц в С. п. составляет при этом лишь $\gamma_0^{1/2}$. Частичная нейтронизация пространственного заряда увеличивает предельный ток.

Поскольку С. п. в магн. поле вращается как целое, ему свойствен сильный диамагнетизм, вплоть до обращения знака (реверса) поля внутри трубчатого пучка (т. н. *E*-слои). С учётом диамагнетизма физически заданным параметром следует считать не ведущее магн. поле, а полный магн. поток, замороженный в камере дрейфа и перераспределяющийся по сечению при инжекции пучка. Для токовостенного заряженного трубчатого пучка в магн. поле характерна неустойчивость, приводящая к разбеганию его на отдельные спиралеобразные струи.

Полностью нейтронизованный С. п. не ограничено по току, но соств. магн. поле сильно фокусирует его

частицы, совершающие поперечные колебания с длиной волны порядка или меньше радиуса пучка. Поэтому ср. поперечный импульс частиц в С. п. больше продольного, а поперечное распределение плотности тока имеет выраженный трубчатый характер.

Зарядовая нейтронизация пучка происходит при инжекции в достаточно плотную плазму за счёт вытеснения из его объёма медленных плазменных электронов с характерным временем $(4\pi\sigma)^{-1}$, где σ — проводимость плазмы. Если к моменту достижения нейтронизации ток С. п. продолжает возрастать, то эдс индукции создаёт ток оставшихся плазменных электронов, направленных против тока пучка и вызывающий токовую нейтронизацию. При небольшой плотности плазмы, когда плазменная частота $\omega_p < c/a$, обратный ток распределён по всему объёму, так что токовая нейтронизация неполна и имеет интегральный характер. При $\omega_p > c/a$ происходит локальная нейтронизация, за исключением поверхности С. п., где образуется двойной токовый слой толщиной $\sim c/\omega_p$ и сосредоточено магн. поле. В таких условиях частицы С. п. практически свободны, а сам он электродинамически ненаблюдим. Эффективность переноса пучком мощности и энергии через плазму па расстояния ~ 1 м близка к 100%, но на больших расстояниях уменьшается за счёт разл. неустойчивостей С. п., в первую очередь поперечной неустойчивости, выражающейся в изгибании пучка как целого и разбегания его на отд. нити.

При инжекции пучка в нейтральный газ существенны процессы нестационарной ионизации, длительность к-рых может быть сравнима с длительностью нс. Вначале за время (для воздуха) порядка $(0,7/p)$ нс, где p — давление газа в мм рт. ст. (торрах), за счёт прямой ионизации образуется кол-во ионов, достаточное для зарядовой нейтронизации, и вторичные электроны перестают уходить поперёк пучка. После этого медленные электроны дают вторичную ионизацию, скорость к-рой определяется ускорением их индукционным электрич. полем и давлением. Если за время существования С. п. успевают развиться ионизаци. лавина, то проводимость скачком возрастает и все дальнейшие изменения тока С. п. т.чю компенсируются обратным током по плазме, что приводит к фиксации степени токовой нейтронизации и конфигурации пучка в момент пробоя. Эффективность распространения мала при малых давлениях (ниже 10^{-3} торр), когда нет даже зарядовой нейтронизации, достигает максимума при давлениях 0,1—1 торр, где может осуществиться токовая нейтронизация, а при больших давлениях падает из-за процессов рассеяния.

С. п. положит. ионов (гл. обр. водорода) снимаются с праводной плотной плазмы, имеющей эмиссионную способность до 1 кА/см², и выводятся в сторону катода. В режиме ограничения пространственным зарядом диодный промежуток в ср. нейтрален, но плотность пологого тока превышает закон «трёх вторых» не более чем в два раза из-за локальной компрессии ионного и электронного потоков. Ионы с массой M дают тогда лишь малую долю $\sim (m/M)^{1/2}$ от полного тока, переносимого в осн. встречными электронами. Для повышения эффективности служит магн. изоляция электронной компонентой, не влияющая на распространение ионов. В рефлексных ионных диодах используется прозрачный для электронов анод, вблизи к-рого создается увеличенная плотность осциллирующих электронов. При этом может быть заметно превышен предел «трёх вторых» для ионов. Совр. конструкции диодов позволяют получать С. п. ионов ~ 1 МА при энергии ~ 1 МэВ и малой ($\leq 1^\circ$) угл. расходимости. Распространение С. п. ионов возможно только в условиях зарядовой нейтронизации медленными сопровождающими электронами.

Лит.: Диденко А. Н., Григорьев В. П., Усов Ю. П., Мощные электронные пучки и их применение, М., 1977; Миллер Р., Введение в физику сильноточных

пучков заряженных частиц, пер. с англ., М., 1984; Быстрых и др. в В. М., Давиденко А. Н., Мощные ионные пучки, М., 1984.

СИЛЬНОТОЧНЫЕ УСКОРИТЕЛИ — установки для получения сильноточных пучков зарядов частиц (электронов и ионов), создающих ток $I > 10^4$ А при энергии частиц $> 10^8$ эВ. С. у. содержит источник импульсов высокого напряжения и вакуумный диод, на к-рый это напряжение подается и в межэлектродном промежутке к-рого происходит ускорение (рис. 1). Большинство С. у. являются ускорителями прямого действия,

диоды, помещенные в анальное магн. поле (рис. 2, а). При большом электронном токе

$$I > 17V \sqrt{2V-1} / \ln(r_a/r_k) \text{ [кА]},$$

где r_a и r_k — радиусы анода и катода, такой диод может работать и без внеш. магн. поля. Чтобы ларморовский радиус электронов стал меньше межэлектродного расстояния и электроны не достигли анода, уже достаточно магн. поля тока, текущего по катодному стержню (явление магн. самоизоляции). В этом случае анодная плазма образуется позднее, а скорость разлета катодной плазмы несколько ограничивается его магн. полем и работоспособное состояние диода может поддерживаться > 10 мкс.

Для генерации ионных пучков анод диода делают из диэлектрика соответствующего хим. состава. В результате пробоя на поверхности анода образуется плазма, из к-рой под действием внеш. поля и поля пространственного заряда электронов эмитируются ионы. Для увеличения энергии в ионном пучке ток электронов, пересекающих диод, должен быть уменьшен, но сохранён большой отриц. пространственный заряд. Для этого используется либо поперечное магн. поле, параллельное поверхности катода (т. н. ионные диоды с магн. и изоляцией, рис. 3, а), либо полупрозрачные для ускоренных электронов аноды, покрытые диэлектриком (т. н. рефлексные диоды и триоды, рис. 3, б). Во втором случае электроны многократно проходят сквозь анод, создавая увеличенный отриц. пространственный заряд, облегчающий вытягивание ионов из плазмы. При прочих равных условиях значение плотности тока ионов оказывается в $V M \sqrt{m_e}$ раз меньше плотности электронного тока. Эффективность новых источников достигает 50–60% при импульсном токе ионов $I_0 \sim 1$ МА и напряжении ~ 1 МВ.

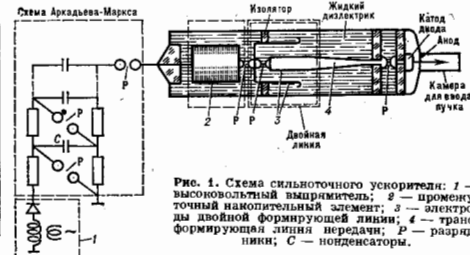


Рис. 1. Схема сильноточного ускорителя: 1 — высоковольтный умножитель; 2 — промежуточный накопительный элемент; 3 — электроды двойной формирующей линии; 4 — трансформирующая линия передачи; Р — разрядники; С — конденсаторы.

в к-рых частицы получают весь прирост энергии за один проход через ускоряющий промежуток (вакуумный диод), на электроде к-рого они и образуются.

Принцип действия. На диод подается напряжение от генератора мощных высоковольтных импульсов. Источником электронов или отриц. ионов служит плазма, образующаяся за неск. нс на катоде в результате ср. напряженности поля на катоде $\sim 10^6$ В/см происходит тепловой взрыв его микронеоднородностей. В ионных диодах плазма создается на аноде и из неё вытягиваются положит. ионы. Для эфф. работы ионного диода сопутствующий электронный ток на анод искусственно подавляют.

Образовавшиеся на катоде и аноде слои плазмы расширяются со скоростью $v = (2-3) \cdot 10^6$ см/с, межэлектродный промежуток (размером d от неск. мм до неск. см) сокращается в течение импульса. При относительно небольших напряжениях V [МВ] в диоде с электродами в виде двух плоских дисков радиуса R (рис. 2, а) течёт равномерно распределённый электронный ток $I = 7,3 V^2 R^2 / d^2$ [кА]. Через время $t_k = d/2v$ оба слоя плазмы соединяются и диод закорачивается. Время устойчивой работы диода, пока его сопротивление не сильно отличается от внутр. сопротивления генератора импульсов, должно быть в неск. раз меньше t_k и обычно не превосходит 100 нс. Это и определяет верх. границу длительности пучка С. у., если не приняты спец. меры для уменьшения v . Для эфф. работы С. у. за это же время в пучок должна быть передана существенная доля первоначально запасённой энергии.

В случае больших напряжений и отношения R/d , т. е. при больших токах, когда ларморовский радиус электронов в собств. магн. поле пучка становится мал по сравнению с зазором (рис. 2, б), диод переходит в режим сильного пинча. При этом эффективно эмитируются только участки поверхности, расположенные на периферии катода, а ток на аноде сфокусируется в центральное пятно малого размера и определяется соотношением:

$$I = 8,5\gamma(R/d) \text{ arch } \gamma \text{ [кА]},$$

где $\gamma \approx 2V + 1$ — полная энергия электронов в единицах энергии покоя $m_0 c^2$. Для формирования выведенного пучка С. у. часто используют цилиндрич.

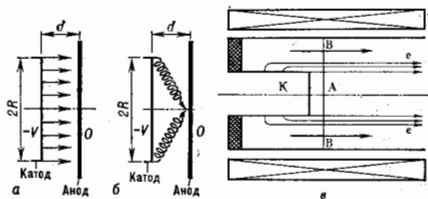


Рис. 2. Траектории электронов в диоде с малым (а) и большим (б) токами; в — в диоде с магнитной изоляцией.

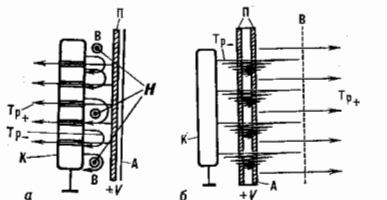


Рис. 3. Схемы ионных диодов с магнитной изоляцией (а) и рефлексных диодов (б): К — катод; А — анод; П — поверхность плазмы; Н — поперечное магнитное поле; Тр₊ — траектории электронов; Тр₋ — траектории ионов; В — виртуальный катод (плоскость остановки электронов).

Генератор мощных высоковольтных импульсов. В большинстве С. у. первичное накопление энергии осуществляется в конденсаторах С (рис. 1) при сравнительно низком напряжении (~100 кВ), после чего следует увеличение напряжения на один-два порядка либо с помощью импульсного трансформатора, либо коммутацией конденсаторной батареи из параллельного соединения в последовательное (схема Аркадьева — Маркса). Если длительность импульса больше времени рабочего состояния диода, то приходится вводить «обостритель» импульсов (усилитель мощности) в одном или нескольких каскадах. Эти каскады обычно выполнены в виде отрезков *линий передач*, погруженных в диэлектрик для увеличения уд. энергоемкости. Для этого используют *жидкие диэлектрики* (трансформаторное и касторовое масло в случае высокого напряжения, вода — низкого), не «запоминающие» пробоев и имеющие повш. электрич. прочность при длительности импульса, меньшей ~1 мкс. Применение воды, имеющей высокую диэлектрич. проницаемость, и следовательно энергоемкость, позволяет сократить размеры линии, но требует тщательной очистки и деионизации, чтобы исключить потери энергии за времена порядка 1—10 мкс. Для малых напряжений и больших токов используются одинарные линии, в обратном случае — двойные (т. е. линии Бломляйна), создающие удвоенное напряжение на нагрузке, к-рой служит диод. В С. у. с малой запасаемой энергией индуктивных источников может непосредственно обеспечить на диоде импульс напряжения длительностью $\lesssim 100$ нс. Такую же схему имеют С. у. с длительностью пучка $\gg 1$ мкс, но в этом случае схема Аркадьева — Маркса обычно собирается из искусств. диальных линий. Это позволяет получить на диоде импульсное напряжение, близкое к прямоугольному.

Поскольку ток и мощность С. у. определяются напряжением генератора высоковольтных импульсов, имеющим естеств. техн. ограничения, для достижения экстремальных параметров используется конструкция из модулей с умеренными параметрами каждого модуля и сложением выходных токов или напряжений спец. сумматорам. Так, в исследованиях по инерциальному УТС мощность пучка должна составлять десятки ТВт при энергии электронов $\sim 10^8$ эВ или легких ионов $\sim 10^7$ эВ. Для создания С. у. с такими выходными параметрами пучков разработаны схемы высоковольтных ускорителей с параллельным включением выходов деск. десятков модулей. Примеры таких установок — Proto-2 и PBFA-2 (США) и «Ангара-5 (СССР) (табл. 1).

Табл. 1. — Параметры сильноточных ускорителей с параллельным соединением модулей

	PBFA-2 (США)	«Ангара-5 (СССР)
Число модулей	36	8 (проект 48)
Энергонап. пучка, МДж	13	0, 7(4, 2)
Мощность пучка, ТВт	100	9(50)
Параметры модуля		
Угол, МВ	6	2, 3
Энергонап., МДж	0, 36	0, 29
Средняя длина линии (вода)		
Тип	одинарная	двойная
Угол, мкс	0, 150	
Угол, МВ	4, 6	2, 1
Угол, нс	50	90
Угол, МВ	2, 7	1, 8
Угол, ТВт	2, 8	1, 1

Для возмещения энергии частиц в С. у. используется последоват. включение модулей, т. е. доускорение пучка. Практически это делается в линейных индукц. ускорителях либо в аналогичной по принципу действия последовательности ускоряющих промежуток, питаемых от обств. линий передачи. Непосредств. суммиро-

вание напряжений модулей до 20 МВ на одном диоде осуществлено в установке «Гермес-III с помощью длинной магнитоизоляров. штока-катододержателя, закрепленного лишь на низковольтном конце и проходящего через все модули.

В табл. 2 приведены нек-рые параметры американских С. у. (уже созданной установки «Гермес и разрабатываемой установки EDNA) с последоват. суммированием напряжений отд. модулей.

Табл. 2. — Параметры сильноточных ускорителей со сложением напряжений модулей

	«Гермес-III (США)	EDNA (США)
Выходное напряжение, МВ	22	47
Выходной ток, МА	0, 73	1, 2
Длительность импульса, нс	40	60
Сумматор		
Длина, м	16	37
Число индукторов	20	40
Напряжение на индукторе, МВ	1, 1	1, 2
Одинарные формирующие линии		
Число	80	160
Импульс, Ом	5	4
Зарядное напряжение, МВ	2, 6	2, 9

Транспортировка пучков С. у. на большое расстояние представляет собой сложную проблему, связанную с преодолением сил пространственного заряда и тока (см. *Сильноточные пучки*). Без компенсации пространственного заряда электронный пучок радиуса a может быть проведен в продольном магн. поле, жесткость к-рого $aB \gg 1, 7 \sqrt{1 + \gamma^2}$ [кГс·см], но макс. ток ограничен теоретич. значением $\approx 8, 5(\gamma^{1/2} - 1)^{1/2} \ln(R/a)[kA]$, где R — радиус канала транспортировки. При наличии в пучке положит. ионов с относит. плотностью $> \gamma^{-3}$ (напр. при распространении в плазме низкой концентрации) поперечное растекание электронов сменяется сжатием. Необходимая плотность ионов устанавливается также при транспортировке электронных пучков в вакуумных каналах, на периферии к-рых имеется или создается самим пучком плотная плазма. Транспортировка ионных пучков С. у. не может быть обеспечена внеш. полями и требует компенсации сил пространственного заряда ионов медленными сопутствующими электронами. На практике такая нейтрализация осуществляется на выходе ионов из диодов.

Применение С. у. служат гл. обр. для нагрева плазм, создания с помощью полей пучка магнитных ловушек и для сжатия микроионной в системах УТС с инерциальным удержанием плазмы. Кроме того, пучки, создаваемые С. у., используются для генерации сверхкоротких импульсов СВЧ-колебаний в диапазоне от субмиллиметровых до дециметровых волн, для накачки *химических лазеров* и *газовых лазеров* высокого давления, в коллективных методах ускорения ионов и т. д.

Лит.: Смирнов В. П., Получение сильноточных пучков электронов, ИТЭУ, 1977, № 2, с. 7; Накопление и коммутация энергии больших плотностей, пер. с англ., М., 1979; Генерация и фокусировка сильноточных релятивистских электронных пучков, М., 1990. А. Н. Лебедев, Б. Н. Яблоков.

СИМЕНС (См, S) — единица СИ электрич. проводимости. Названа в честь Э. В. Сименса (E. W. Siemens), 1 См равен электрич. проводимости проводника, имеющего сопротивление 1 Ом.

СИММЕТРИЯ в физике и ме. В том случае, когда состояние системы не меняется в результате к.-л. преобразования, к-рому она может быть подвергнута, говорят, что система обладает С. относительно данного преобразования. С. физ. системы определяется С. её *гамма-функции* (или в квантовой механике — *гамма-матрица*), т. е. преобразованиями С. для физ. системы являются преобразования, не ме-

янию её гомалингована. В математике такие преобразования составляют группу Фунда. а значение S в физике определяется прежде всего тем, что каждому непрерывному преобразованию S отвечает *сохранения закон* нек-рой физ. величины, связанной с указанной S (см. *Нётер теорема*). Т. о., само существование сохраняющихся физ. величин обусловлено определёнными типами S , а физ. величинами выступают в качестве генераторов соответствующих преобразований.

С др. стороны, осн. принципом совр. калибровочных теорий фундам. взаимодействий природы (напр., сильного и электрослабого), заключающийся в том, что в качестве источников калибровочных полей — переносчиков взаимодействия — выступают определённые сохраняющиеся величины, игнорирующие тем самым роль «зарядов», может быть реализовано только при наличии вполне определённых локальных S . Существование такого рода S однозначно определяет у-ряния, описывающие поведение калибровочных полей. Т. о., симметрия взаимодействий в этом случае полностью определяет их динамику. Подобный подход может быть использован и в теории гравитации. Поэтому соображения о S взаимодействий лежат в основе попыток построения единой теории всех сил природы (см. *Великое объединение*).

Спец. вопросом является теория S . молекул и кристаллов, к-рая, используя теоретико-групповые методы, устанавливает классы *симметрии кристаллов*, типы *симметрии молекул*, классификацию их термов, возможность переходов между ними и т. д. На основе теории S дается описание физ. явлений в средах с определённой S .

Среди разных типов S различают пространственно-временные S и внутренние S .

Пространственно-временные симметрии

Пространственно-временные S являются наиб. общими S природы. Их можно разделить на S , связанные с непрерывными и дискретными преобразованиями.

К непрерывным преобразованиям относятся следующие.

(1) Перенос (сдвиг) системы как целого в пространстве [пространственно-временные преобразования (1) — (4) можно понимать в двух смыслах: как активное преобразование — реальный перенос физ. системы относительно выбранной системы отсчёта; как пассивное преобразование — параллельный перенос системы отсчёта]. S . физ. законов относительно сдвигов в пространстве означает эквивалентность всех точек пространства, т. е. отсутствие в пространстве к.-л. выделенных точек (однородность пространства).

(2) Изменение начала отсчёта времени (сдвиг во времени); S . относительно этого преобразования означает эквивалентность всех моментов времени (однородность времени), благодаря к-рой физ. законы не меняются со временем.

(3) Поворот системы как целого в пространстве; S . физ. законов относительно этого преобразования означает эквивалентность всех направлений в пространстве (изотропность пространства).

(4) Переход к системе отсчёта, движущейся относительно данной системы с постоянной (по направлению и величине) скоростью. S . относительно этого преобразования означает, в частности, эквивалентность всех инерциальных систем отсчёта.

Все указанные S отражают свойства плоского 4-мерного пространства Минковского с псевдоевклидовой метрикой (см. *Относительности теория*). Преобразования (1) и (2) представляют сдвиги, а (3) и (4) — повороты в пространстве Минковского. S . относительно первых двух преобразований приводит к законам сохранения импульса и энергии, а S . относительно пово-

ротов — к закону сохранения момента и равномерному прямолинейному движению центра инерции физ. систем (в инерциальной системе координат).

Это имеет глубокий смысл. Поскольку при всех наблюдениях изучается не само пространство, а поведение материальных объектов (в т. ч. и распространение света), то, по мысли А. Пуанкаре (А. Poincaré), не может существовать «абсолютная» геометрия пространства, оторванная от физ. явлений. Геом. аксиомы, согласно Пуанкаре, представляют собой условные положения (соглашения), при выборе к-рых руководствуются лишь опытными фактами, но сам выбор остаётся свободным и ограничен только необходимостью избежать внутр. противоречий. Евклидова геометрия, по мысли Пуанкаре, является предпочтительной, т. к. она проще других геометрий и в достаточной степени согласуется со свойствами твёрдых тел. Однако Пуанкаре упускал связь S . пространства с законами сохранения. Если принять в качестве постулата независимое существование всех перечисленных выше законов сохранения, связывающих все возможные процессы в природе (независимо от того, какими силами они вызываются), то 4-мерное пространство Минковского с псевдоевклидовой метрикой может рассматриваться именно в качестве «абсолютной» геометрии пространства-времени. При этом в пространстве Минковского может быть построена и релятивистская теория гравитации, результаты к-рой для экспериментально наблюдавшихся в Солнечной системе явлений совпадают с выводами *общей теории относительности* А. Эйнштейна (А. Einstein) (ОТО). Риманово пространство ОТО с точки зрения этой теории является «эффективным» пространством, к-рое не может иметь сложной топологии, поскольку «кривизна» её связана с универсальным «искривлением» движения материальных объектов под действием гравитации, поля в пространстве Минковского. В такой теории естественно выполняются все законы сохранения и возможна локализация энергии — импульса гравитации, поля, не существующая в римановом пространстве (напр., для сильных гравитационных полей).

Дискретные пространственно-временные симметрии

Слабое и сильное отражение. $СРТ$ -симметрия. Из свойств пространства Минковского и осн. положений квантовой теории поля следует, что для любой частицы, обладающей к.-л. зарядом, должна существовать симметричная ей *античастица* (обладающая той же массой, временем жизни и спином, но с противоположным значением заряда), а также необходимость определённой S . между движениями частиц и античастиц. Основой для указанной S . является то, что одновременно, отражение всех пространственных осей (P) и временной оси (T) (т. е. переход к зеркальной системе пространственных координат и отсчёт времени в обратном направлении) формально сводится к повороту в пространстве Минковского на миним. угол (в евклидовом пространстве чётное число отражений сводится к реальному повороту). Поэтому теория, удовлетворяющая требованиям релятивистской инвариантности, т. е. инвариантная относительно поворотов в пространстве Минковского, должна быть инвариантна и относительно T . и слабого отражения (PT). (То, что при этом повороте осуществляется на миним. угол, не имеет принципиального значения, по крайней мере, для теорий с локальным взаимодействием частиц с нуклонным спином.)

Поскольку при слабом отражении энергии и импульса частиц меняются на противоположные значения, инвариантность теории относительно слабого отражения, казалось бы, приводит к существованию физических недолустимых состояний с отрицат. энергиями. В квантовой теории поля это можно устранить, истолковав движение частиц с отрицат. энергиями как обратное по времени, зеркально симметричное движение частиц с положит. энергиями, но с противоположными значе-

нием яряда. Т. о., необходимость существования античастиц следует из требования релятивистской инвариантности и положительности энергии. (По существу из тех же самых требований вытекает связь спина частиц с их статистикой — см. *Паули теорема*.) Законы природы оказываются, следовательно, симметричными относительно т. н. сильного отражения (CPT) , заключающегося в одновременном проведении слабого отражения и зарядового сопряжения (C) (т. е. перехода от частиц к античастицам). Это утверждение составляет содержание *теоремы CPT*, согласно к-рой для любого движения частиц может осуществляться в природе симметричное ему (обращенное во времени, зеркально отраженное) движение античастиц.

Несмотря на то что из общих принципов теории следует С. лишь относительно одноврем. проведения преобразований P, T, C , в широком классе явлений существует С. по отношению к каждому из указанных преобразований в отдельности.

Зеркальная симметрия (S , относительно инверсии P). Осуществляется в процессах, выполняемых сильными и эл.-магн. взаимодействиями, а также в системах, связанных с помощью этих взаимодействий (атомах, атомных ядрах, молекулах, кристаллах и т. д.). Наличие зеркальной S означает, что для любого процесса, обусловленного сильными или эл.-магн. взаимодействиями, с равной вероятностью могут осуществляться два зеркально-симметричных перехода. Это обуславливает, напр., симметричность относительно плоскости, перпендикулярной спину, угл. распределения квантов, испускаемых поляризов. ядрами (поскольку вероятности вылета n -кванта под углами θ и $\pi - \theta$ к спину ядра одинаковы; $w(\theta) = w(\pi - \theta)$). Зеркально-симметричные состояния отличаются друг от друга противоположными направлениями скоростей (импульсов) частиц и электрич. полей и спинов частиц. С. гамма-тоннава относительно пространственной инверсии отвечает закон сохранения пространственной четности системы. Пространственная четность, подобно др. величинам, существующая в квант. механике с дискретными S , не имеет аналога в классич. механике (т. к. в последней нет понятия относ. фазы между состояниями), однако она может служить характеристической волновых движений (напр., в волноводах).

Наличие зеркальной S гамма-тоннава взаимодействия не исключает возможности существования физ. состояний, где такая S нарушена. Примером могут служить изомерные молекулы, к-рые вращают плоскость поляризации света в противоположные стороны. Существование *изомерии молекулы* явно нарушает зеркальную S и представляет собой случай т. н. *спонтанного нарушения симметрии*. Общая S гамма-тоннава относительно инверсий проявляется в том, что для любой, напр. левовращающей, молекулы существует правовращающий изомер, представляющий собой зеркальное изображение первой. Формальное нарушение зеркальной S связано, т. о., в этом случае с *вырождением* осн. состояния и асимметрией физ. вакуума для света, распространяющегося в веществе из одних правовращающих или левовращающих молекул.

Зарядовая симметрия

Сильные и эл.-магн. взаимодействия инвариантны относительно операции зарядового сопряжения: замены всех частиц на соответствующие им античастицы. Эта S является пространственной и рассматривается в этом разделе из-за её связи с CPT -симметрией. Зарядовая S приводит к закону сохранения особой величины — *зарядовой четности* (или S -четности), характеризующей истинно нейтральную частицу (или систему частиц, не обладающую к.-л. зарядом), переходящую сама в себя при зарядовом сопряжении.

CP-симметрия

S гамма-тоннава относительно преобразования пространственной инверсии одновременно с зарядовым сопряжением (комбиниров. инверсия) наз. CP -симметрией. Поскольку сильные и эл.-магн. взаимодействия симметричны относительно каждого из этих преобразований, они симметричны и относительно комбиниров. инверсии. Однако относительно этого преобразования оказываются симметричными и слабые взаимодействия, к-рые не обладают S по отношению к преобразованию инверсии и зарядовому сопряжению в отдельности. С. процессов слабого взаимодействия относительно комбиниров. инверсии может служить указанием на то, что отсутствие зеркальной S в них связано со структурой элементарных частиц и что античастицы по своей структуре являются как бы «зеркальным изображением» соответствующих частиц. В этом смысле процессы слабого взаимодействия, происходящие с к.-л. частицами, и соответствующие процессы с их античастицами связаны между собой так же, как и явления в оптич. изомерах.

Открытие распадов долгоживущих K_L^0 -мезонов на два π -мезона и наличие зарядовой асимметрии в распадах $K_L^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- \nu_e (\pi^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu)$ и $K_L^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- \bar{\nu}_e (\pi^- \mu^+ \nu_\mu)$ (см. *K-мезоны*) указывают на существование сил, несимметричных относительно комбиниров. инверсии. Пока не установлено, являются ли эти силы малыми добавками к известным фундам. взаимодействиям (сильному, эл.-магн., слабому) или же имеют особую природу. Возможно, что нарушение CP -симметрии связано со спонтанным нарушением S физ. вакуума в нашей области Вселенной.

Симметрия относительно обращения времени (T)

Благодаря существованию CPT - и CP -симметрии как для сильных, так и для электрослабых взаимодействий (исключая взаимодействие, нарушающее CP -симметрию) выполняется S относительно обращения времени. Она означает, что любому движению под действием этих сил соответствует в природе симметричное движение, при к-ром система переходит в обратном порядке все состояния, что и в первоначальном движении, но с измененными на противоположные направлениями скоростей частиц, спинами и магн. полями. Из T -симметрии следуют соотношения между прямыми и обратными реакциями, позволяющие экспериментально проверить выполнение T -инвариантности в разл. процессах (см. *Детальное рассмотрение принципа*), а также ряд др. заключений (см., напр., *Крамерса теорема*).

Симметрия относительно перестановки одинаковых частиц

При квантовомеханич. описании систем, содержащих одинаковые частицы, эта S приводит к принципу неразличимости одинаковых частиц, к полной их тождественности. Волновая ф-ция системы симметрична относительно перестановки любой пары одинаковых частиц с целым спином (т. е. перестановки их пространственных и спиновых переменных) и антисимметрична относительно такой перестановки для частиц с полуполым спином. Связь спина и статистики является следствием релятивистской инвариантности теории и тесно связана с CPT -теоремой.

Симметрия (или антисимметрия) волновой ф-ции относительно перестановки одинаковых частиц является простейшим (одномерным) *представлением группы перестановок*. В принципе математически возможно существование более сложных (многомерных) представлений этой группы (см. *Парастатистика*). Реальные более сложные типы S возникают отдельно для кординатных (или спиновых) волновых ф-ций одинаковых частиц, когда рассматриваются перестановки только

координат (или только спинов) одинаковых частиц (см. Юнга *схемы*).

Внутренние симметрии

Под внутренними С. понимают С. между частицами (в квантовой теории поля — между полями) с различными внутренними *квантовыми числами*. Среди различных внутр. С. можно выделить глобальные S. и локальные С.

Глобальные С. Примером такой С. является инвариантность лагранжиана относительно следующих *калибровочных преобразований* входящих в него полей:

$$\psi_i \rightarrow \psi_i' = \exp(i\alpha Q_i) \psi_i, \quad \psi_i^* \rightarrow (\psi_i')^* = (\psi_i^*)^* \exp(-i\alpha Q_i), \quad (1)$$

где α — произвольное число, а числа Q_i фиксированы для каждого поля ψ_i . Эта инвариантность приводит к аддитивному закону сохранения заряда $\sum_i Q_i =$

$= \text{const}$. Наряду с электрическими в качестве зарядов могут выступать и др. заряды: барионный, лептонный, странность и т. д. Инвариантность относительно преобразования (1) выполняется, когда в лагранжиан симметрично в виде комбинации $(\psi_i + \psi_{i\bar{c}})$ входят два действительных поля ψ_{i1} и ψ_{i2} (с одинаковыми массами). В этом случае они могут быть заменены комплексными полями

$$\psi_i = 1/\sqrt{2} (\psi_{i1} + i\psi_{i2}) \quad \text{и} \quad \psi_i^* = 1/\sqrt{2} (\psi_{i1}^* - i\psi_{i2}^*).$$

Преобразование (1) отвечает преобразованию «поворота» полей вокруг фиксиров. осей:

$$\begin{aligned} \psi_{i1}' &= \psi_{i1} \cos \alpha - \psi_{i2} \sin \alpha, \\ \psi_{i2}' &= \psi_{i2} \sin \alpha + \psi_{i1} \cos \alpha. \end{aligned} \quad (2)$$

Симметрия (1) наз. *глобальной С.*, если параметр преобразования α не зависит от пространственно-временных координат точки, в к-рой рассматривается поле. Преобразования (1) с разл. параметрами α коммутируют между собой и составляют *абелеву группу* $U(1)$ (см. *Симметрия* $U(1)$). Если лагранжиан симметричен относительно преобразований «поворотов» нек. комплексных полей, то возникают более сложные, *неабелевы* группы С. с нек. параметрами, напр. группа $SU(2)$ для *изотопического спина* (см. *Симметрия* $SU(2)$), группа $SU(3)$ для цветовой С. [$SU(3)$, см. *Цвет, Симметрия* $SU(3)$] или С. между *ароматами* кварков [$SU_f(3)$]. Во всех случаях С. наз. *глобальной*, если параметры преобразований не зависят от пространственно-временных координат.

Дополнительная, т. е. киральная симметрия возникает для частиц нулевой массы. Поскольку для безмассовых частиц сохраняется их *спиральность*, наличие к.-л. внутр. С. для них приводит к тому, что она может выполняться независимо для левых и правых частиц (с положит. и отрицат. спиральностью). Так, для безмассовых *u-, d-кварков* должна быть группа С. $SU_L(2) \times SU_R(2)$.

Локальные С. Если параметры преобразований для глобальных С. можно рассматривать как произвольные ф-ции пространственно-временных координат, то говорят, что соответствующие С. выполняются локально. Предположение о существовании локальной С. позволяет построить теорию, в к-рой сохраняющиеся (благодаря наличию глобальной С.) величины (заряды) выступают в качестве источников особых *калибровочных полей*, нероспавших взаимодействие между частицами, обладающими соответствующими зарядами. Поскольку во всякую динамич. теорию входит обобщенный импульс, оператор к-рого $\hat{P}_\mu = i\partial/\partial x^\mu$ при дейст-

вии на преобразованное поле приводит в случае локальной С. к появлению произвольных ф-ций [напр., $iQ\partial/\partial x^\mu$ для преобразования (1)], то инвариантность теории возможна лишь при условии, когда возникающий произвол каким-то образом компенсируется. Такая компенсация оказывается возможной, если обобщенный импульс входит в теорию в комбинации с нек-рыми векторным полем, соответственно изменяющимся при калибровочных преобразованиях. Т. о., локальная С. может осуществляться только при наличии компенсирующих (калибровочных) полей. Для локальной $U(1)$ -симметрии обобщенный импульс должен входить в комбинации $\hat{P}_\mu - QA_\mu$ с векторным полем A_μ , к-рое при преобразованиях (1) изменяется по закону $A'_\mu = A_\mu - \partial\alpha/\partial x^\mu$.

Произвол, существующий в определении поля A_μ (произвольная ф-ция $\partial\alpha/\partial x^\mu$), устраняется в тензоре

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}.$$

Поэтому физ. величинами являются компоненты тензора $F_{\mu\nu}$, из к-рого однозначно строится лагранжиан поля A_μ .

Для локальных неабелевых С. необходимо существование нек. векторных калибровочных полей, к-рые в этом случае будут сами обладать «зарядами» и взаимодействовать между собой. Требование отсутствия калибровочного произвола в физ. величинах позволяет однозначно установить закон взаимодействия этих полей. Впервые модель с локальной изотопической $SU(2)$ -симметрией была рассмотрена Ч. Янгом (Ch. Yang) и Р. Л. Миллсом (R. L. Mills) в 1954. Успех *квантовой хромодинамики*, построенной на основе локальной цветовой $SU_C(3)$ -симметрии и теории *электрослабых взаимодействий*, позволяет предположить, что требование локальной С. является общим принципом построения теории фундаментальных взаимодействий. Исходя из этих принципов строятся разл. модели *Великого объединения*, в к-рых пытаются учесть наблюдаемую в электрослабом взаимодействии С. между лептонами и кварками, С. между разл. поколениями лептонов и кварков, а также использовать предполагаемую суперсимметрию, связывающую частицы с целым и полуделым спином (см. *Суперсимметрия, Супергравитация*).

Нарушение симметрии

Многие из С. природы являются приближенными или нарушенными. Следует различать при этом явное и *спонтанное нарушение симметрии*. Явное нарушение С. обусловлено нарушением С. эффективного гамильтониана системы [напр., нарушение изотопич. инвариантности и $SU_f(3)$ -симметрии по ароматам кварков связано с различием их масс]. Спонтанное нарушение С. происходит из-за нарушения С. вакуума, к-рый при симметричном гамильтониане может быть вырожденным (см. *Вырождение вакуума*). Спонтанное нарушение глобальных С. приводит к появлению безмассовых (голдстоуновских) частиц (см. *Голдстоуна теорема, Голдстоуновские бозоны*). Спонтанное нарушение калибровочных С. может, наоборот, приводить к тому, что безмассовые частицы, отвечающие калибровочным полям (какими являются, напр., поля промежуточных W^\pm и Z^0 -бозонов), приобретают массу (см. *Хиггса бозон*). Спонтанное нарушение дискретных С. может быть в принципе причиной появления P - или CP -несимметричных вакуумов в определенных частях Вселенной и объяснять наблюдаемые явления нарушения P - или CP -четности.

При достижении высоких энергий, когда становятся возможными переходы между различными физ. вакуумами, спонтанно нарушенная С. может восстанавливаться.

Симметрия квантовомеханических систем и вырождение

Если квантовомеханич. система обладает определенной С., то операторы сохраняющихся физ. величин, соответствующих этой С., коммутируют с гамильтонианом системы. Если не-рыс из этих операторов не коммутируют между собой, уровни энергии системы оказываются вырожденными (см. *Вырождение*): определенному уровню энергии отвечают неск. различных состояний, преобразующихся друг через друга при преобразованиях С. В матем. отношении эти состояния представляют базис невырожденного представления группы С. системы. Это обуславливает плодотворность применения методов теории групп в квантовой механике.

Помимо вырождения уровней энергии, связанного с явной С. системы (напр., относительно поворотов системы как целого), в ряде задач существует дополнит. вырождение, связанное с т. н. скрытой С. взаимодействия. Такие скрытые С. существуют, напр., для кулоновского взаимодействия и для изотропного осциллятора. Скрытая С. кулоновского взаимодействия, приводящая к вырождению состояний с разл. орбитальными моментами, обусловлена, как показал В. А. Фок (1935), явной С. кулоновского взаимодействия в 4-мерном импульсном пространстве.

Если система, обладающая к.-л. С., находится в поле сил, нарушающих эту С. (но достаточно слабых, чтобы их можно было рассматривать как малое возмущение), происходит расщепление вырожденных уровней энергии исходной системы: разл. состояния, к-рые в силу С. системы имели одинаковую энергию, под действием «несимметричного» возмущения приобретают разл. энергетич. смещения, а в случаях, когда возмущающее поле обладает нек-рой С., составляющей часть С. исходной системы, вырождение уровней энергии снимается не полностью: часть уровней остается вырожденной в соответствии с С. взаимодействия, «включающей» возмущающее поле.

Наличие в системе вырожденных по энергии состояний в свою очередь указывает на существование С. взаимодействия и позволяет в принципе выявить эту С., когда она заранее неизвестна. Последнее обстоятельство играет важнейшую роль, напр., в физике элементарных частиц.

Динамические симметрии

Оказалось плодотворным понятие т. н. динамич. С. системы, к-рое возникает, когда рассматриваются преобразования, включающие переходы между состояниями системы с разл. энергиями. Невырожденным представлением группы динамич. С. будет весь спектр стационарных состояний системы. Понятие динамич. С. можно распространить и на случаи, когда гамильтониан системы зависит от времени, причём в одно невырожденное представление динамич. группы С. объединяются в этом случае все состояния квантовомеханич. системы, не являющиеся стационарными (т. е. не обладающие заданной энергией).

Лит.: Вигнер Е., Элементы симметрии, пер. с англ., М., 1974; Гибсон У., Поллард В., Принципы симметрии в физике элементарных частиц, пер. с англ., М., 1979; Уанкар А., О науке, пер. с франц., М., 1983; Эддингс Дж., Дюбер П., Симметрия в физике, пер. с англ., т. 1—2, М., 1983; Логунин А. А., Лекции по теории относительности и гравитации, М., 1987; Фейнман Р., Характер физических законов, пер. с англ., М., 1987. С. С. Герштейн.

СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ — свойство кристаллов совмещаться с собой при поворотах, отражениях, параллельных переносах либо при части или комбинации этих операций. Симметрия внеш. формы (гранки) кристалла определяется симметрией его атомного строения, к-рая обуславливает также и симметрию физ. свойств кристалла.

На рис. 1а изображён кристалл кварца. Внеш. его форма такова, что поворотом на 120° вокруг оси

З он может быть совмещён сам с собой (совместимое равенство). Кристалл метасиликата натрия (рис. 1, б) преобразуется в себя отражением в плоскости симметрии m (зеркальное равенство).

Если $F(x_1, x_2, x_3)$ — функция, описывающая объект, напр. форму кристалла в трёхмерном пространстве или к.-л. его свойство, а операция $g[x_1, x_2, x_3]$ осуществляет преобразование координат всех точек объекта, то g является операцией, или преобразованием с симметрией, а F — симметричным объектом, если выполняются условия:

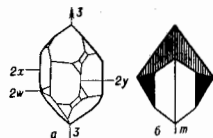
$$g[x_1, x_2, x_3] = x'_1, x'_2, x'_3, \quad (1a)$$

$$F(x_1, x_2, x_3) = F[x'_1, x'_2, x'_3]. \quad (1b)$$

В наиб. общей формулировке симметрия — неизменность (инвариантность) объектов и законов при нек-рых преобразованиях описывающих их переменных. Кристаллы — объекты в трёхмерном пространстве, поэтому классич. теория С. к. — теория симметричных преобразований в себе трёхмерного пространства с учётом того, что внутр. атомная структура кристаллов дискретная, трёхмерно-периодическая. При преобразованиях симметрии пространство не деформируется, а преобразуется как жёсткое целое. Такие преобразования наз. ортогональными или изометрическими. После преобразования симметрии части объекта, находящиеся в одном месте, совпадают с частями, находящимися в др. месте. Это означает, что в симметричном объекте есть равные части (совместимые или зеркальные).

С. к. проявляется не только в их структуре и свойствах в реальном трёхмерном пространстве, но также и при описании энергетич. спектра электронов кристалла (см. *Зонная теория*), при анализе процессов дифракции рентгеновских лучей, дифракции нейтронов и дифракции электронов в кристаллах с использованием обратного пространства (см. *Обратная решётка*) и т. п.

Группы симметрии кристаллов. Кристаллу может быть присуща не одна, а неск. операций симметрии. Так, кристалл кварца (рис. 1, а) совмещается с собой не только при повороте на 120° вокруг оси z (операция g_1), но и при повороте вокруг оси z на 240° (операция g_2), а также при поворотах на 180° вокруг осей $2x, 2y, 2z$ (операции g_3, g_4, g_5). Каждой операции симметрии может быть сопоставлен элемент симметрии — прямая, плоскость или точка, относительно к-рой производится данная операция. Напр., ось z или ось $2x, 2y, 2z$ являются осями симметрии, плоскость m (рис. 1, б) — плоскостью зеркальной симметрии и т. п. Совокупность операций симметрии $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ данного кристалла образует группу симметрии G в $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ в смысле матем. теории групп. Последоват. проведение двух операций симметрии также является операцией симметрии. В теории групп это обозначают как произведение операций: $g_i g_k = g_l$. Всегда существует операция идентичности g_0 , ничего не изменяющая в кристалле, наз. тождественным, она геометрически соответствует шевелению объекта или повороту его на 360° вокруг любой оси. Число операций, образующих группу G , наз. порядком группы.



Группы симметрии преобразований пространства классифицируют по числу n измерений пространства, в n -рых они определены; по числу m измерений пространства, в n -рых объект периодичен (их соответственно обозначают G_m^n), и по нек-рым др. признакам. Для описания кристаллов используют различные группы симметрии, из n -рых важнейшими являются точечные группы симметрии G_2^3 , описывающие внеш. форму кристаллов; их наз. также кристаллографич. классами; пространственные группы симметрии G_3^3 , описывающие атомную структуру кристаллов.

Точечные группы симметрии. Операциями точечной симметрии являются: повороты \bar{N} вокруг оси симметрии порядка N на угол, равный $360^\circ/N$ (рис. 2, а); отражение в плоскости симметрии m (зеркальное отражение, рис. 2, б); инверсия $\bar{1}$ (симметрия относительно точки, рис. 2, в); инверсионные повороты \bar{N} (комбинация поворота на угол $360^\circ/N$ с одновр. инверсией, рис. 2, г). Вместо

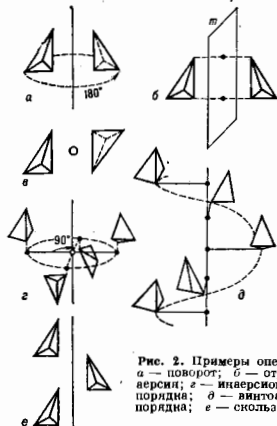


Рис. 2. Примеры операций симметрии: а — поворот; б — отражение; в — инверсия; г — инверсионный поворот 4-го порядка; д — винтовой поворот 4-го порядка; е — скользящее отражение.

инверсионных поворотов иногда рассматриваются аксиальные или зеркальные повороты N . Геометрически возможные сочетания операций точечной симметрии, n -рая изображается обычно в стереографич. проекции. При преобразовании n точечной симметрии по крайней мере одна точка объекта остаётся неподвижной — преобразуется сама в себя. В ней пересекаются все элементы симметрии, и она является центром стереографич. проекции. Примеры кристаллов, относящихся к различным точечным группам, даны на рис. 3.

Точечные преобразования симметрии $g(x_1, x_2, x_3) = x'_1, x'_2, x'_3$ описываются линейными уравнениями

$$\begin{aligned} x'_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, \\ x'_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3, \\ x'_3 &= a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{aligned} \quad (2a)$$

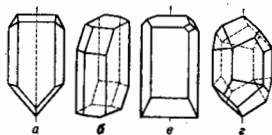


Рис. 3. Примеры кристаллов, принадлежащих к разным точечным группам (кристаллографическим классам): а — к классу m (одна плоскость симметрии); б — к классу $\bar{1}$ (центр симметрии или центр инверсии); в — к классу 2 (одна ось симметрии 2-го порядка); г — к классу $\bar{6}$ (одна инверсионно-поворотная ось 6-го порядка).

или матрицей коэффициентов

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{ij}). \quad (3)$$

Напр., при повороте вокруг оси x_1 на угол $\alpha = 360^\circ/N$ матрица D имеет вид:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix},$$

а при отражении в плоскости x_1x_2 D имеет вид:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

Число точечных групп G_2^3 бесконечно. Однако в кристаллах ввиду наличия кристаллич. решётки возможны только операции и соответственно оси симметрии до 6-го порядка (кроме 5-го; в кристаллич. решётке не может быть оси симметрии 5-го порядка, т. к. с помощью пятиугольных фигур нельзя заполнить пространство без промежутков). Операции точечной симметрии и соответствующие им элементы симметрии обозначаются символами: оси 1, 2, 3, 4, 6, инверсионные оси $\bar{1}$ (центр симметрии или центр инверсии), $\bar{2}$ (она же — плоскость симметрии m), $\bar{3}$, $\bar{4}$, $\bar{6}$ (рис. 4).

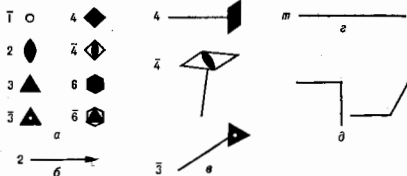


Рис. 4. Графические обозначения элементов точечной симметрии: а — кружок — центр симметрии, ось симметрии, перпендикулярные плоскости чертежа; б — ось 2, параллельные плоскости чертежа; в — ось симметрии, параллельные или перпендикулярные плоскости чертежа; г — ось симметрии, перпендикулярная плоскости чертежа; д — плоскости симметрии, параллельные плоскости чертежа.

Для описания точечной группы симметрии достаточно задать одну или неск. порождающих её операций симметрии, остальные её операции (если они есть) возникают в результате взаимодействия порождающих. Напр., для кварца (рис. 1, а) порождающими операциями являются 3 и одна из операций 2, а всего операций в этой группе 6. В международном обозначении групп входят символы порождающих операций симметрии. Точечные

группы объединяются по точечной симметрии формы элементарной ячейки (с периодами a, b, c и углами α, β, γ) в 7 симгоний (табл. 1).

Группы, содержащие кроме гл. оси N плоскости симметрии m , обозначаются как N/m , если $\perp N$ или Nm , если ось лежит в плоскости m . Если группа помимо гл. оси имеет неск. проходящих через неё плоскостей симметрии, то она обозначается Nmm .

Табл. 1. — Точечные группы (классы) симметрии кристаллов

Сингония	Обозначения групп		Название класса (группы)
	мендугар.	по Шёнфлюсу	
Тригональная $a=b \neq c$ $\alpha=\beta \neq \gamma=90^\circ$	1	C_1	Монокристаллический
	$\bar{1}$	C_1	Пинакоидальный
Моноклинивая $a \neq b \neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ$ $\gamma \neq 90^\circ$	2	C_2	Диэдрический осевой
	m	C_2	Диэдрический бесосевный
	$2/m$	C_{2h}	Призматический
Ромбическая $a \neq b \neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	222	D_2	Ромбо-тетраэдрический
	$mm2$	C_{2v}	Ромбо-пирамидальный
	mmm	C_{3h}	Ромбо-дипирамидальный
Тетрагональная $a=b \neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	4	C_4	Тетрагонально-пирамидальный
	442	D_4	Тетрагонально-трапецоэдрический
	4/m	C_{4h}	Тетрагонально-дипирамидальный
	4mm	C_{4v}	Дитетрагонально-пирамидальный
	4/mmm	D_{2d}	Дитетрагонально-дипирамидальный
	$\bar{4}$	S_4	Тетрагонально-тетраэдрический
	42m	D_{2d}	Тетрагонально-скаленоэдрический
Тригональная (в ромбоэдрической установке) $a=b \neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	3	C_3	Тригонально-пирамидальный
	32	D_3	Тригонально-трапецоэдрический
(возможно описание и в гексагональных координатах)	3m	C_{3h}	Дитригонально-пирамидальный
	$\bar{3}$	C_{3i}	Ромбоэдрический
	$\bar{3}m$	D_{3d}	Дитригонально-скаленоэдрический
Гексагональная $a=b \neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ$ $\gamma=120^\circ$	6	C_6	Тригонально-дипирамидальный
	$\bar{6}m2$	D_{3h}	Дитригонально-дипирамидальный
	6	C_6	Гексагонально-пирамидальный
	622	D_6	Гексагонально-трапецоэдрический
	6/m	C_{3h}	Гексагонально-дипирамидальный
	6mm	C_{6v}	Дигексагонально-пирамидальный
	6/mmm	D_{3h}	Дигексагонально-дипирамидальный
Кубическая $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	23	T	Тритетраэдрический
	$m\bar{3}$	T_h	Дидодекаэдрический
	$\bar{4}3m$	O	Гексаоктаэдрический
	432	O_h	Триоктаэдрический
	$m\bar{3}m$	O_h	Гексоктаэдрический

Группы, содержащие лишь повороты, описывают кристаллы, состоящие только из совместно равных частей (группы 1-го рода). Группы, содержащие отражения или инверсионные повороты, описывают кристаллы, в к-рых есть зеркально равные части (группы 2-го рода). Кристаллы, описываемые группами 1-го рода, могут кристаллизоваться в двух энантиоморфных формах («справой» и «слево»), каждая из к-рых не содержит элементов симметрии 2-го рода, но зеркально-равных друг другу (см. *Энантиоморфия*).

Группы C_n несут в себе геом. смысл: каждой из операций $g \in G$ соответствует, напр., поворот вокруг оси симметрии, отражение в плоскости. Нек-рые точечные группы в смысле теории групп, учитывающей лишь правила взаимодействия операций $g_1 g_2 = g_3$ в данной группе (но не их геом. смысл), оказываются одинаковыми, или изоморфными друг другу. Таковы, напр., группы 4 и $\bar{4}$; $2/m, mm2, 222$. Всего имеется 18 абстрактных групп, изоморфных одной или нескольким из 32 точечных групп C_n .

Точечные группы описывают симметрию не только кристаллов, но любых конечных фигур. В живой природе часто наблюдается запрещённая в кристаллографии точечная симметрия с осями 5-го, 7-го порядка и выше. Для описания регулярной структуры сферич. вирусов, в оболочках к-рых наблюдаются приципы плотной упаковки молекул, и нек-рых теоретич. молекул оказались важными икосаэдрич. точечные группы 532 и $m\bar{5}m$ (см. *Биологический кристалл*). Икосаэдрич. симметрия наблюдается также в *кварикристаллах*.

Предельные группы. Ф-ции, к-рые описывают зависимость различных свойств кристалла от направления, имеют определённую точечную симметрию, однократно связанную с группой симметрии ограничения кристалла. Она либо совпадает с ней, либо выше неё по симметрии (*Неймана прицип*).

В отношении макроскопич. свойств кристалл может описываться как однородная непрерывная среда. Поэтому многие из свойств кристаллов, принадлежащих к тем или иным точечным группам симметрии, описываются т. н. предельными точечными группами, содержа-

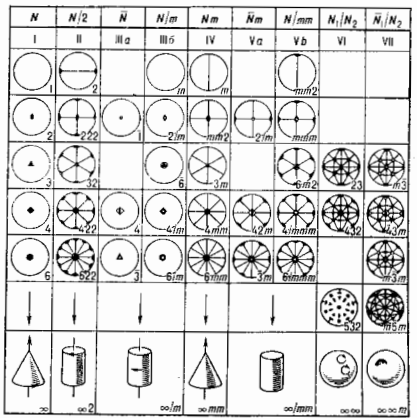


Fig. 5. Стереографические проекции 32 кристаллографических и 2 икосаэдрических групп. Группы расположены в колонки по семействам, символы которых даны в верхнем ряду. В нижнем ряду указаны предельная группа каждого семейства и изображены фигуры, иллюстрирующие предельную группу.

щими осью симметрии бесконечного порядка, обозначаемые символом ∞ . Наличие оси ∞ означает, что объект совмещается с собой при повороте на любой, в т. ч. бесконечно малый, угол. Таких групп 7 (рис. 5). Т. о., всего имеется $32 + 7 = 39$ точечных групп, описывающих симметрию свойств кристаллов. Зная группу симметрии кристаллов, можно указать возможность наличия или отсутствия в нём пек-рых физ. свойств (см. Кристаллофизика).

Пространственные группы симметрии. Пространственная симметрия атомной структуры кристаллов описывается пространственными группами симметрии G_3 . Они наз. также фёдоровскими в честь нашедшего их в 1890 Е. С. Фёдорова; эти группы были независимо выведены в том же году А. Шёнфлисом (А. Schoenflies). В противоположность точечным группам, к-рые были получены как обобщение закономерностей форм кристаллит. многогранников (С. И. Гессель, 1830, А. В. Гадолин, 1867), пространственные группы явились продуктом математич.-геом. теории, предвосхитившей эксперим. определения структуры кристаллов с помощью дифракции рентг. лучей.

Характерными для атомной структуры кристаллово-операциями являются 3 некомпланарные трансляции a, b, c , к-рые и задают трёхмерную периодичность кристаллит. решётки. Кристаллит. решётка рассматривается как бесконечная во всех трёх измерениях. Такое матем. приближение реально, т. к. число элементарных ячеек в наблюдаемых кристаллах очень велико. Перенос структуры на векторы a, b, c или любой вектор $t = p_1a + p_2b + p_3c$, где p_1, p_2, p_3 — любые целые числа, совмещает структуру кристалла с собой и, следовательно, является операцией симметрии (трансляционная симметрия).

Физ. дискретность кристаллит. вещества выражается в его атомном строении. Пространственные группы G_3 — это группы преобразования в себя трёхмерного однородного дискретного пространства. Дискретность заключается в том, что не все точки такого пространства симметричны равны друг другу, напр. атом одного и атом др. сорта, ядро и электрон. Условия однородности и дискретности определяет тот факт, что пространственные группы — трёхмерно периодические, т. е. любая группа G_3 содержит подгруппу трансляций T — кристаллит. решётку.

Вследствие возможности комбинирования в решётке трансляций и операций точечной симметрии в группах G_3 кроме операций точечной симметрии возникают операции и соответствующие им элементы симметрии с трансляц. компонентой — в и т о н о в ы е о с и различных порядков и плоскости скользщего отражения (рис. 2, д, е).

В соответствии с точечной симметрией формы элементарной ячейки (элементарного параллелепипеда) пространственные группы, как и точечные, подразделяются на 7 кристаллографических симфоний (табл. 2). Дальнейшее их подразделение соответствует трансляц. группам и соответствующим им Браве решёткам. Решётки Браве 14, из них 7 — примитивные решётки соответствующих симфоний, они обозначаются P (кроме ромбодрической R). Другие — 7 центров решётки: базо (боку) — центрированные A (центрируется грань bc), B (грань ac), C (ab); объёмноцентрированные I , гранцентрированные (по всем 3 граням) F . С учётом центровки как операции трансляций t добавляются соответствующие центру центрирующие переносы t_c . Если комбинировать друг с другом эти операции $t + t_c$ и с операциями точечных групп соответствующей симфонии, то получаются 73 пространственные группы, наз. сим м о р ф н ы м и.

Т а б л. 2. — Пространственные группы симметрии

Сингония	Обозначения по Шёнфлису	Международ. обозначения
Триклинная	C_1	$P1$
	C_2	$P2$
Моноклинная	$C_2 - C_2$	$P2, P2_1, C_2$
	$C_2 - C_2$	Pm, Pc, Cm, Cc
Ромбическая	$C_2 - C_2 - C_2$	$P2/m, P2/m, C2/m, P2/c, P2/c, C2/c$
	$D_2 - D_2$	$P222, P22_2, P2_12_1, P2_12_12_1, C222, C22_2, F222, I22_2, I2_12_12_1$
	$C_{2v} - C_{2v}$	$Pmm2, Pmc2_1, Pcc2, Pma2, Pca2, Pnc2, Pmns, Pnac2, Pmc2, Pmn2, Cmm2, Cmc2, Ccc2, Amm2, A2m2, Ama2, Abo2, Fmm2, Fdd2, Imm2, Iba2, Ima2$
	$D_{2h} - D_{2h}$	$Pmm, Pmm, Pccm, Pbam, Pmma, Pmm, Pmm, Pbcn, Pbcn, Pbcm, Cmmm, Cmma, Cmmm, Cmmm, Cmma, Ccca, Fmmm, Fddd, Immm, Ibam, Ibaa, Imma$
Тетрагональная	$C_4 - C_4$	$P4, P4_1, P4_2, P4_3, I4, I4_1$
	$S_4 - S_4$	$P4_2, I4$
	$C_{4h} - C_{4h}$	$P4/m, P4_2/m, P4/m, P4_2/n, I4/m, I4_1/a$
	$D_2 - D_2$	$P422, P4_22_2, P4_22_2, P4_22_22_2, P4_22_2, P4_22_2, P4_22_2, P4_22_2, I422, I4_22_2$
	$C_{4v} - C_{4v}$	$P4mm, P4_2m, P4_2c, P4_2m, P4cc, P4nc, P4_2mc, P4_2bc, I4mm, I4cm, I4md, I4cd$
Тригональная	$D_{3d} - D_{3d}$	$P6_3/m, P4_2c, P4_2m, P4_2c, P4_2m, P4_2c, P4_2m, P4_2c, I4_2d, I4_2d, I4_2d$
	$D_{3h} - D_{3h}$	$P6_3/mmm, P4_2/mcc, P4_2/nm, P4_2/nnc, P4_2/mnm, P4_2/mnc, P4_2/mnm, P4_2/ncc, P4_2/nnc, P4_2/mnm, P4_2/ncc, P4_2/nnc, P4_2/nmc, P4_2/ncc, P4_2/nmc, P4_2/ncc, I4_2/amd, I4_2/acd$
	$C_3 - C_3$	$P3, P3_1, P3_2, R3$
Гексагональная	$C_6 - C_6$	$P6, R6$
	$D_3 - D_3$	$P312, P321, P3_12, P3_21, P3_12, P3_21, R32$
	$C_6 - C_6$	$P6_3m, P6_3im, P6_3c, P6_3ic, R6m, R3c$
	$D_{3d} - D_{3d}$	$P6_3/m, P6_3ic, P6_3im, P6_3ic, R6m, R3c$
	$C_2 - C_2$	$P6, P6_1, P6_1, P6_2, P6_2, P6_2$
	$C_3 - C_3$	$P6/m, P6_3/m$
Кубическая	$D_4 - D_4$	$P622, P6_22_2, P6_22_2, P6_22_2, P6_22_2, P6_22_2, P6_22_2$
	$C_4 - C_4$	$P6mm, P6cc, P6_2cm, P6_2mc$
	$D_{2d} - D_{2d}$	$P6_22_2, P6_22_2, P6_22_2, P6_2c$
	$D_{3h} - D_{3h}$	$P6_3/mmm, P6_3mcc, P6_3/mcm, P6_3/mnc$
	$T - T$	$P23, F23, I23, P2_3, I2_3$
	$T_h - T_h$	$Pm3, Pn3, Pn3, Fd3, I3m, Pa3, Ia3$
	$O - O$	$P432, P4_32, F432, F4_32, I432, P4_32, P4_32, I4_32$
	$T_d - T_d$	$P4_3m, P4_3m, P4_3m, F4_3c, F4_3c, I4_3d$
	$O_h - O_h$	$Pm3m, Pn3m, Pm3m, Fm3m, Fm3m, Fm3m, Fd3m, Fd3m, Im3m, Ia3d$

На основе определённых правил из симморфных пространственных групп можно извлечь нетривиальные подгруппы, что даёт ещё 157 несимморфных пространственных групп. Всего пространственных групп 230. Операции симметрии при преобразованиях точки x в симметрично равную ей x' (а значит, и всего пространства в себя) записываются в виде: $x' = Dx + \alpha(D) + t + t_c$, где D — точечное преобразование, $\alpha(D)$ — компоненты винтового поворота или скользящего отражения, $t + t_c$ — операции трансляции группы Браве. Операции винтовой симметрии и соответствующие им элементы симметрии — винтовые оси имеют угол компоненты $\alpha_s = 2\pi/N$ ($N = 2, 3, 4, 6$) и трансляционную $t_s = -itq/N$, где t — трансляция решётки, поворот на α_s происходит одновременно с трансляцией вдоль оси N , q — индекс винтового поворота. Общий символ винтовых осей N_q (рис. 6). Винтовые оси направлены вдоль гл. осей или диагоналей элементарной ячейки. Оси 3_1 и 3_2 , 4_1 и 4_2 , 6_1 и 6_2 , 6_3 и 6_4 соответствуют попарно правым и левым винтовым поворотам. Кроме операции зеркальной симметрии в пространственных группах возможны также плоскости скользящего отражения a , b , c : отражение сочетается с переносом на половину

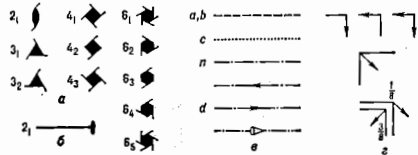


Рис. 6. а — Графические обозначения винтовых осей, перпендикулярных плоскости рис.; б — винтовая ось, лежащая в плоскости рис.; а — плоскости скользящего отражения, перпендикулярные плоскости рис.; г, д, е — периоды элементарной ячейки, вдоль осей которых происходит скользящее трансляционная компонента $a/2$). n — диагональная плоскость скользящего отражения (трансляционная компонента $(a+b)/2$), d — алмазная плоскость скольжения ($n \pm b \pm c/4$); e — то же в плоскости рисунка.

соответствующего периода решётки. Переносу на половину диагонали грани ячейки соответствует т. н. клиновидная плоскость скольжения n , кроме того, в тетрагональных и кубич. группах возможны «алмазные» плоскости d .

В табл. 2 даны интернациональные символы всех 230 пространственных групп в соответствии с их принадлежностью к одной из 7 сингоний и классу точечной симметрии.

Трансляц. компоненты операций микросимметрии пространственных групп макроскопически в точечных группах не проявляются; напр., винтовая ось в границе кристаллов проявляется как соответствующая по порядку простая поворотная ось. Поэтому каждая из 230 групп G_3^3 макроскопически сходственна (гомоморфна) с одной из 32 точечных групп. Напр., на точечную группу $D_{2h} - mmm$ гомоморфно отображаются 28 пространственных групп.

Обозначения Шенфлиса пространственных групп — это обозначение соответственной точечной группы (напр., D_{2h} , табл. 1), к-рому сверху присписан приятный исторически порядковый номер, напр. $D_{2h}^1 - D_{2h}^{25}$. В международных обозначениях указывается символ решётки Браве и порождающие операции симметрии каждой группы — $P2_1, Cmc2_1, R\bar{3}c, Im\bar{3}m$ и т. д. Последовательность расположения пространственных групп в табл. 2 в международных обозначениях соответствует номеру (верхнему индексу) в обозначениях Шенфлиса.

На рис. 7 дано изображение пространств группы $D_{2h}^{16} - Pnma$ согласно Интернациональным кристаллографич. таблицам. Операции (и соответствующие им элементы) симметрии каждой пространственной группы, указываемые для элементарной ячейки, действуют на всё кристаллич. пространство, всю атомную структуру кристалла и друг на друга.

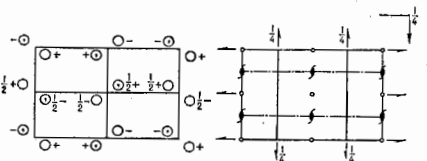


Рис. 7. Изображение группы $D_{2h}^{16} - Pnma$ в Интернациональных таблицах.

Если задать внутри элементарной ячейки к.н. точку $x(x_1, x_2)$, то операции симметрии преобразуют её в симметрично равные ей точки во всём кристаллич. пространстве; таких точек бесконечное множество. Но достаточно описать их положение в одной элементарной ячейке, и эта совокупность уже будет размножаться трансляциями решётки. Совокупность точек, выводимых из данной операции g_i группы $G - x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, наз. правильной системой точек (ПСТ). На рис. 7 справа дано расположение элементов симметрии группы D_{2h}^{16} , слева — изображение ПСТ общего

положения этой группы. Точка общего положения — это такие точки, к-рые не расположены на элементе точечной симметрии пространственной группы. Число (кратность) таких точек равно порядку группы. Точки, расположенные на элементе (или элементах) точечной симметрии, образуют ПСТ ч. а с с и о г о л о ж е н и я и обладают соответственной симметрией, количество их в доле число раз меньше кратности ПСТ общего положения. На рис. 7 слева кружками указаны точки общего положения, их внутри элементарной ячейки 8, символы $\{+\rightarrow x \leftarrow -\}$, $\{1/2 \rightarrow x \leftarrow 1/2 - \rightarrow\}$ означают соответственно координаты $+x, -x, 1/2 + x, 1/2 - x$. Залпные или их отсутствие означают попарное зеркальное равенство соответствующих точек относительно плоскостей симметрии m , имеющих в данной группе при $y = 1/4$ и $3/4$. Если же точка попадает на плоскость m , то она этой плоскостью не удаляется, как в случае точек общего положения, и число (кратность) таких точек частного положения 4, их симметрия — m . То же имеет место при попадании точки в центры симметрии.

Для каждой пространственной группы имеются свои собственные ПСТ. Правильная система точек общего положения для каждой группы одна. Но некоторые из ПСТ частного положения могут оказаться одинаковыми для различных групп. В Интернациональных таблицах указаны кратность ПСТ, их симметрия и координаты и все др. характеристики каждой пространственной группы. Важность понятия ПСТ состоит в том, что в любой кристаллич. структуре, принадлежащей данной пространственной группе, атомы или центры молекул располагаются по ПСТ (одной или нескольким). При структурном анализе распределение атомов по одной или нескольк. ПСТ данной пространственной группы производится с учётом хим. ф-ий кристалла и данных дифракц. эксперимента, позволяет находить координаты точек частных или общих положений, в к-рых расположены атомы. Поскольку каждая ПСТ состоит из одной или кратного числа решёток Браве, то и расположение атомов можно представлять себе как совокупность «вдвину-

тых друг в друга решётки Браве. Такое представление эквивалентно тому, что пространственная группа содержит в себе как подгруппу трансляц. группы Браве.

Подгруппы группы симметрии кристаллов. Если часть операции к.-л. группы G_j (g_1, \dots, g_n) сама образует группу G_k (g_1, \dots, g_m), $m < n$, $G_j \in G_k$, то последняя наз. подгруппой первой. Напр., подгруппами точечной группы 32 (рис. 1, а) являются группы 3 и группа 2. Также и среди пространств. групп существует иерархия подгрупп. Пространственные группы могут иметь в качестве подгрупп точечные группы (таких пространственных групп 217) и подгруппы, к-рые являются пространственными группами более низкого порядка. Соответственно существует иерархия подгрупп.

Большинство пространственных групп симметрии кристаллов различны между собой и как абстрактные группы; число абстрактных групп изоморфных 230 пространственным группам равно 219. Абстрактно равными оказываются 11 зеркально-равных (эантиоморфных) пространственных групп — одна лишь с правыми, другие с левыми винтовыми осями. Таковы, напр., $P3_121$ и $P3_221$. Обе эти пространственные группы гомоморфно отображаются на точечную группу 32, к к-рой принадлежит кварц, но кварц соответственно бывает правый и левый; симметрия пространственной структуры в этом случае выражается макроскопически, но точечная группа в обоих случаях та же.

Роль пространственных групп симметрии кристаллов. Пространственные группы симметрии кристаллов — основа теории кристаллографии, дифракционных и иных методов определения атомной структуры кристаллов и описания кристаллич. структур.

Дифракционная картина, получаемая методом рентгенографии, нейтрографии или электрографии, позволяет установить симметрии и геом. характеристики обратной решётки кристалла, а следовательно и самой структуры кристалла. Так определяют точечную группу кристалла и элементарную ячейку; по характерным погасаниям (отсутствию определённых дифракционных рефлексов) определяют тип решётки Браве и принадлежность к той или иной пространственной группе. Размещение атомов в элементарной ячейке находят по совокупности интенсивностей дифракционных рефлексов.

Большую роль играют пространственные группы в кристаллохимии. Определено более 100 тыс. кристаллич. структур неорганич., органич. и биологич. соединений. Любой кристалл относится к одной из 230 пространственных групп. Оказалось, что почти все пространственные группы реализованы в мире кристаллов, хотя одна из них встречается чаще, другие реже. Имеется статистика распространённости пространственных групп по различным видам хим. соединений. Пока не найдены среди исследованных структур лишь 4 группы: $Pcc2$, $P4_3cm$, $P43m$, $P6mm$. Теория, объясняющая распространённость тех или иных пространственных групп, учитывает размеры составляющих структуру атомов, понятия плотной упаковки атомов или молекул, роль «упаковочных» элементов симметрии — плоскостей скольжения и винтовых осей.

В физике твёрдого тела используется теория представлений групп с помощью матриц и спец. ф-ций, для пространственных групп эти ф-ции периодичны. Так, в теории структурных фазовых переходов 2-го рода пространственная группа симметрии менее симметричной (низкотемпературной) фазы является подгруппой пространственной группы более симметричной фазы и фазовый переход связан с одним из неприводимых представлений пространственной группы высокосимметричной фазы. Теория представлений позволяет также решать задачи динамики кристаллической решётки, её электронной и магн. структур, ряда физ. свойств.

В теории кристаллографии пространственные группы позволяют развить теорию разбиения пространства на равные области, в частности полздрические.

Симметрия проекций, слоёв и цепей. Проекция кристаллич. структур на плоскость описывается плоскими группами G_2 , их число — 17. Для описания трёхмерных объектов, периодических в 1 или 2 направлениях, в частности фрагмента структуры кристаллов, могут быть использованы группы G_3^2 — двумерно периодические и G_1^3 — одномерно периодические. Эти группы играют важную роль в изучении биологич. структур и молекул. Напр., группы G_2^2 описывают строение биологич. мембран, группы G_1^3 — ценных молекул (рис. 8, а), палочкообразных вирусов, трубчатых кристаллов

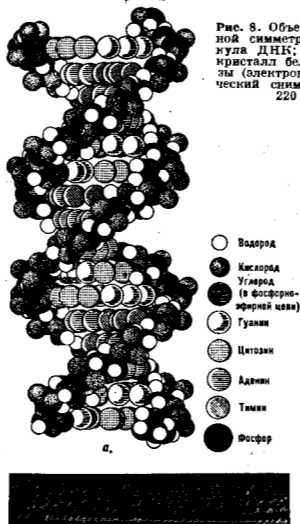


Рис. 8. Объекты со спиральной симметрией: а — молекула ДНК; б — трубчатый кристалл белка фосфорамиды (электронно-микроскопический снимок, увеличение 220 000).

глобулярных белков (рис. 8, б), в к-рых молекулы расположены согласно спиральной (винтовой) симметрии, возможной в группах G_1^3 (см. Биологический кристалл).

Структура квазикристаллов. Квазикристаллы (напр., $Al_{13}Mg_{74}$) имеют икосаэдрич. точечную симметрию (рис. 5), к-рая невозможна в кристаллич. решётке. Дальний порядок в квазикристаллах — квазипериодический, описываемый на основе теории почти периодич. ф-ций. Структура квазикристаллов может быть представлена как проекция на трёхмерное пространство шестимерной периодич. кубич. решётки с осями 5-го порядка. Квазикристаллы с пятимерной симметрией в высшем измерении могут иметь 3 типа решёток Браве (примитивную, объёмноцентрированную и гранецентрированную) и 11 пространственных групп. Др. возможные типы квазикристаллов — укладки в столку двумерных сеток атомов с осями 5-, 7-, 8-, 10-, 12-го ... порядков, с периодичностью вдоль третьего перпендикулярного сеткам направления.

Обобщённая симметрия. В основе определения симметрии лежит понятие равенства (1,б) при преобразовании (1,а). Однако физически (и математически) объ-

ект может быть равен себе по одним признакам и не равен по другим. Напр., распределение ядер и электронов в кристалле антиферромагнетика можно описать с помощью обычной пространственной симметрии, но если учесть распределение в нём магн. моментов (рис. 9),

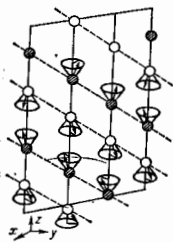


Рис. 9. Распределение магнитных моментов (стрелки) в элементарной ячейке ферримагнитного кристалла, описываемое с помощью обобщённой симметрии.

то «обычной», классич. симметрии уже недостаточно. К подобного рода обобщениям симметрии относятся антисимметрия и цветная симметрия.

В антисимметрии в дополнение к трём пространственным переменным x_1, x_2, x_3 вводится добавочная, 4-я переменная $x_4 = \pm 1$. Это можно истолковать таким образом, что при преобразованиях (1,а) функции F может быть не только равна себе, как в (1,б), но и «антиравна» — изменит знак. Существует 58 групп точечной антисимметрии G_3^a и 1651 пространственная группа антисимметрии G_3^a (шубниковские группы).

Если добавочная переменная приобретает не два значения, а больше (возможны 3, 4, 6, 8, ..., 43), возникает т. н. цветная симметрия Белова. Так, известна 81 точечная группа G_3^c и 2942 группы G_3^c . Осн. приложения обобщённой симметрии в кристаллографии — описание магн. структур.

Найдены др. группы антисимметрии (краткой и др.). Теоретически выведены и все точечные и пространственные группы четырёхмерного пространства и более высоких измерений. На основе рассмотренной симметрии (3 + K)-мерного пространства можно также описывать несозерцаемые в трёх направлениях модуляторы, структуры (см. Несоразмерная структура).

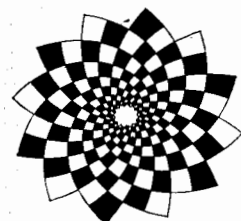


Рис. 10. Фигура, обладающая симметрией подобия.

Лит.: Шубников А. В., Копчик В. А. Симметрия в науке и искусстве, 2 изд., М., 1972; Федоров Е. С., Симметрия и структура кристаллов, М., 1949; Шубников А. В., Симметрия и асимметрия колеблющихся фигур, М., 1951; International Tables for X-ray Crystallography, V. 1 — Symmetry groups, Birmingham, 1952; Ковалев О. В. Непригодные представления пространственных групп, К., 1961; Вейль Г., Симметрия, пер. с англ., М., 1968; Современная кристаллография, т. 1 — Вайнштейн Б. К., Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии, М., 1978; Галдуля Р. В., Кристаллографическая геометрия, М., 1964; International Tables for Crystallography, V. A — Space group symmetry, Dordrecht — la. o. J., 1987. В. К. Вайнштейн.

фин, т. 1 — Вайнштейн Б. К., Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии, М., 1978; Галдуля Р. В., Кристаллографическая геометрия, М., 1964; International Tables for Crystallography, V. A — Space group symmetry, Dordrecht — la. o. J., 1987. В. К. Вайнштейн.

СИММЕТРИЯ МОЛЕКУЛ. С. м. играет фундам. роль в молекулярной спектроскопии, позволяет проводить классификацию уровней энергии молекул, определить отбора правила для молекул, существенно упрощает аналитич. и численные расчёты внутр. энергий и вероятностей переходов молекул.

В наиб. общем виде С. м. определяется как группа преобразований, оставляющих полный гамильтонова молекул инвариантным, и состоит из следующих операций:

- а) все перестановки координат и спинов электронов;
- б) любое вращение координат и спинов всех частиц (электронов и ядер) вокруг любой оси (оси симметрии), проходящей через центр масс молекулы;
- в) любая трансляция молекулы в пространстве;
- г) обращение знака всех линейных и угл. моментов, эквивалентное обращению времени;
- д) одноврем. инверсия координат всех частиц в центре масс;
- е) любая перестановка координат и спинов тождественных ядер.

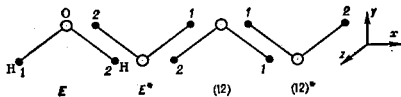
Каждый из наборов этих операций составляет отдельную группу, а каждая группа симметрии гамильтонова представляет собой прямое произведение всех этих групп. При решении конкретных задач используют не все перечисленные группы. Группа (а) используется только в связи с Паули принципом, согласно к-рому волновая ф-ция электрона антисимметрична относительно любой перестановки электронов; группа (б) отражает закон сохранения для полного угл. момента молекулы; группа (в) для изолиров. молекул несущественна, т. к. трансляция молекулы не влияет на волновые ф-ции, описывающие внутр. состояние молекулы; инвариантность гамильтонова относительно групп (г) и (д) показывает, что он может содержать только чётные степени угл. моментов и пространственных декартовых координат частиц.

Для молекул наиб. важны группы (а) и прямое произведение групп (д) и (е), к-рое представляет собой т. н. перестановочно-спиновую и-пересконую (ПШ) группу С. м. ПШ-группы введены в теорию С. м. Х. К. Лонге-Хиггинсом (H. Ch. Longuet-Higgins) в 1963. Частным случаем ПШ-групп являются точечные группы С. м. Группы (б), (в) и (г) лишь накладывают на гамильтонова молекулы определённые условия, к-рые учитываются при решении конкретных задач. Для групп С. м. применяют обозначения, заимствованные из кристаллографии (см. Симметрия кристаллов).

ПШ-группа симметрии молекул представляет собой прямое произведение групп перестановок тождественных ядер (E, P) на группу инверсии (E, E^*), где E — идентичная операция, E^* — инверсия, P — перестановка. ПШ-группа состоит из перестановок P тождественных ядер, перестановок с инверсией $P^* = PE^* = E^*P$ и идентичной операции E , просто инверсия E может не быть элементом ПШ-группы. Для молекул, содержащих много тождественных ядер размерность ПШ-группы может быть очень большой, т. к. она определяется только хим. ф-лой молекулы. Напр., полная ПШ-группа молекулы $C_2H_4Cl_2$ состоит из $2 \cdot 6! \cdot 5! \cdot 1! = 2 \cdot 720 \cdot 120 \cdot 1 = 172 800$ операций, и очевидно, что такая группа для практич. целей бесполозна. Лонге-Хиггинс предложил поступать, согласно к-рому из полной группы выбирается подгруппа, элементы к-рой соответствуют физически возможным операциям. Физически невозможными считаются операции, отвечающие разрыву хим. связей, и операции переходов между равновесными конфигурациями молекул, разделёнными высокими потенциальными барьерами. После исключения таких физически невозможных операций

получается ПИ-группа обычно небольшой размерности, к-рая и используется при классификации уровней энергии молекулы. Напр., для $C_6H_6Cl_6$ такая подгруппа состоит всего из 4 элементов и изоморфна точечной группе симметрии C_{2v} (см. ниже).

В нек-рых случаях полная ПИ-группа состоит только из физических возможных операций. Напр., ПИ-группа молекулы H_2O состоит из 4 операций: E , перестановки (12), E^* и (12)*, к-рые графически можно представить в виде:



где каждый вид молекулы получен из первого с помощью операции, указанной под ним. Эта ПИ-группа изоморфна точечной группе C_{2v} , состоящей из чисто геом. операций вращения C_2 вокруг биссектрисы валентного угла H_1OH_2 на 180° , отражения σ_{xz} на плоскости молекулы и отражения σ_{yz} на плоскости, проходящей через ось C_2 и перпендикулярной плоскости молекулы. Изоморфизм выражается следующими тождествами:

$$E \equiv E, (12) \equiv R_{2y}C_2, E^* = R_{xz}\sigma_{xz}, (12)^* = R_{xz}\sigma_{yz}, (1)$$

где R_{2x} , R_{2y} , R_{2z} — операции вращения на 180° вокруг осей x , y , z соответственно.

В случае H_2O все операции ПИ-группы физически осуществимы, т. к. молекула H_2O имеет только одну равновесную конфигурацию. Если молекула имеет неск. равновесных конфигураций, то ПИ-группа имеет подгруппу, к-рая изоморфна точечной группе симметрии одной из равновесных конфигураций. Напр., полная ПИ-группа молекулы NH_3 состоит из элементов:

$$E, (123), (132), (12)^*, (13)^*, (23)^*, (24)^*, (132)^*, (132)^*(12), (13), (23), (24)$$

где (123) обозначает циклич. перестановку трёх протонов, (12), (13), (23) — парные перестановки, а (...) — парные перестановки с последующей инверсией. ПИ-группа изоморфна точечной группе D_{3h} , но элементы в (2a) [а также и в (26)] составляют подгруппу, к-рая изоморфна точечной группе D_{3h} . Подгруппа (2a) описывает также геом. симметрию пирамидальной равновесной конфигурации NH_3 , подгруппа (26) описывает геом. симметрию др. пирамидальной равновесной конфигурации NH_3 , получаемой от первой при инверсии. Поэтому если инверсионный потенциальный барьер не высок и туннелирование через него наблюдается в виде туннельного расщепления вырожденных уровней (см. *Молекула*), то следует использовать для классификации уровней энергии ПИ-группу или точечную группу D_{3h} ; если туннельное расщепление не наблюдается, то можно использовать группу C_{3v} . Для NH_3 инверсионный барьер составляет ок. 2000 см^{-1} (в единицах частоты перехода) и инверсионное туннельное расщепление уровней, равное в основном колебл. состоянии $0,8 \text{ см}^{-1}$, в первом возбужденном колебл. состоянии $3,6 \text{ см}^{-1}$, во 2-м — 285 см^{-1} , легко наблюдается. Поэтому для NH_3 использовать группу D_{3h} . Для молекул PH_3 , AsH_3 , SbH_3 инверсионное расщепление в низких колебл. состояниях не наблюдается, и для них используется группа C_{3v} . Интересно также пример молекулы N_2H_4 (гидразин), равновесная конфигурация к-рой имеет низкую геом. симметрию C_2 , во, т. к. инверсия на обоих атомах азота и внутр. вращение вокруг связи $N-N$ имеют достаточно высокие барьеры, ПИ-группа состоит из 16 физических возможных операций и изоморфна точечной группе D_{2h} ; фактически происходит туннелирование гидразина между 8 эквивалентными равновесными конфигура-

циями и уровни жёсткой конфигурации с симметрией C_2 расщепляются в соответствии с корреляцией между этими симметриями групп C_2 и D_{2h} .

Точечные группы симметрии молекул. Как было указано выше, симметрия равновесной конфигурации молекулы описывается точечной группой, к-рая может быть изоморфна подгруппе ПИ-группы или самой ПИ-группе. Точечные группы состоят из чисто геом. операций поворотов и отражений, переводящих равновесную конфигурацию молекулы в саму себя. Точечная группа таа, потому что по крайней мере одна точка молекулы при операциях точечной группы симметрии остаётся неподвижной. Элементами таких групп кроме идентичной операции E могут быть: поворот C_n вокруг оси симметрии n -го порядка, отражение σ на плоскости, содержащей ось C_n , отражение σ_h на плоскости, перпендикулярной к оси C_n , и инверсия i (не следует путать с E^*). Напр., группа C_{2v} состоит из E , поворота вокруг оси C_2 на 180° и двух отражений на взаимно перпендикулярных плоскостях с осью пересечения на C_2 ; группа C_{3v} состоит из E , поворотов C_3 и C_3^2 вокруг оси C_3 на 120° и 240° , трёх отражений σ на плоскостях, проходящих через ось C_3 .

Ось, характеристиками точечной группы (как и ПИ-группы) являются их неприводимые представления (см. *Представление группы*), наз. также типами симметрии, к-рые определяют свойства преобразования волновых ф-ций при операциях точечной группы. Типы симметрии обозначают буквами A, B, E, F (или T) с индексами 1, 2, ..., g, u . Буквами A и B обозначают одномерные неприводимые представления, или вырожденные типы симметрии. Так, A_{1g} означает, что волновая ф-ция типа A_{1g} поллосимметрична относительно всех операций точечной группы. Если волновая ф-ция симметрична относительно операции поворота вокруг оси, она обозначается буквой A , а если антисимметрична, — буквой B . Индексы 1 и 2 указывают симметричность и антисимметричность ф-ции относительно отражения на плоскости σ , верхние индексы ' и " — относительно отражения на плоскости σ_h . Буквой E (от нем. *entartet* — вырожденный) обозначают дважды вырожденные, а буквой F (или T) трижды вырожденный тип симметрии. Напр., точечная группа T_d молекулы CH_4 состоит из 24 операций и имеет типы симметрии A_1, A_2, E, F_1 и F_2 . ПИ-группа CH_4 состоит из $2 \cdot 4! = 48$ операций и изоморфна прямому произведению $E^* \times T_d$, но инверсия связана с преодолением очень высокого барьера. Поэтому уровни типа A_1, A_2 и т. д. CH_4 фактически состоят из двух инверсионных подуровней с одинаковой энергией, обозначаемых верхними индексами \leftarrow и \rightarrow , к-рые указывают симметрию и антисимметрию относительно пространственной инверсии: $A_1^+, A_1^-, A_2^+, A_2^-$ и т. д. На практике часто используются характеры неприводимых представлений точечных групп, таблицы к-рых приводятся обычно в литературе по теории групп и по молекулярной спектроскопии.

Классификация нормальных колебаний молекулы по типам симметрии. Молекула, состоящая из N атомов, имеет $3N$ степеней свободы (N — число атомов в молекуле), из к-рых $3N - 6$ связаны с отнес. движением атомов — их колебаниями, а остальные 6 относятся к вращениям и поступат. движениям молекулы в целом. Для симметричных молекул смещения атомов в данном колебании или вращении (трансляция) относятся к определённому типу симметрии точечной группы или ПИ-группы. Число степеней свободы типа симметрии Γ_i определяется по ф-ле

$$n_i = \frac{1}{g} \sum_{\Gamma} (\chi_i^{\Gamma})^* \chi_i^{\Gamma} \quad (3)$$

где χ_r — характер приводимого представления для операции r (т. е. представления размерности $3N \times 3N$, по k -рому преобразуются произвольно выбранные смещения атомов), χ_r^* — характер неприводимого представления Γ_r , индекс \leftrightarrow указывает на комплексное сопряжение, g — порядок точечной группы. Характеристики χ_r определяются по поведению декартовых координат атомов при операциях точечной группы. При идентичной операции E все координаты всех атомов остаются неизменными, поэтому $\chi_E = g$. Если при операции r атомы меняются местами, то их вклад в χ_r равен нулю. Напр., для H_2O $\chi_E = 9$, $\chi_{C_2} = -1$ [H_{O1} и H_{O2} меняются местами, $y(0)$ остаётся неизменной, а $x(0)$ и $z(0)$ меняют знак], $\chi_{C_{2v}} = 1$, $\chi_{C_{2v}^*} = 1$. Характеристики χ_r^* приведены в табл.:

γ	E	C_2	C_{2v}	C_{2v}^*	T, R
A_1	1	1	1	1	T_x
A_2	1	1	1	-1	R_y
B_1	1	-1	-1	-1	R_x, R_z
B_2	1	-1	-1	1	T_z, R_z

В последнем столбце даны типы симметрии вращений и трансляций (относительно осей x, y, z) молекулы в целом. Тогда из (3) следует

$$n_{A_1} = 3, n_{A_2} = 1, n_{B_1} = 3, n_{B_2} = 2. \quad (4)$$

За вычетом трёх вращений и трёх трансляций получим колебания типа A_1 и одно колебание типа B_1 , к-рые обозначаются также символами $\nu_1, \nu_2(A_1)$ и $\nu_3(B_1)$.

Осн. колебат. состояние всегда относится к типу A_1 . Первое возбуждённое состояние колебания типа Γ принадлежит к тому же типу симметрии Γ , типы симметрии более высоких возбуждённых состояний определяются из прямых произведений симметризованных степеней типов симметрии возбуждённых колебаний. Если в данном состоянии молекулы возбуждено n колебаний типа Γ , то тип симметрии такого состояния определяется из прямого произведения симметризов. степеней $[\Gamma^n]$, $[\Gamma^{n-1}]$ и т. д. Напр., тип симметрии состояния с возбуждением одного колебания $\nu_3(B_1)$ и двух квантов колебания $\nu_1(A_1)$ молекулы NH_3 будет $E \times [E^2] = E \times (A_1 + E) = E = A_1 + A_2 + E = A_1 + A_2 + 2E$.

Модельные симметрии. Если молекула не содержит тождественных ядер, то её ПИ-группа сводится к группе инверсий (E, E^*); симметричные и антисимметричные состояния такой молекулы (напр., CH_3FCN) могут отличаться по энергии только за счёт слабых электрон-ядерных взаимодействий. Однако и для таких молекул при решении конкретных модельных задач часто оказываются полезными группы симметрии более высоких порядков. Напр., в теории вращат. спектров в качестве нулевого приближения используется модель жёсткого волчка, к-рой присуща своя симметрия. Гамильтонова молекулы типа жёсткого асимметричного волчка

$$\hat{H} = B_x J_x^2 + B_y J_y^2 + B_z J_z^2 \quad (5)$$

инвариантен относительно поворотов на 180° вокруг k -ой оси инерции x, y, z (J_x, J_y, J_z — соответствующие моменты), т. е. относительно операций точечной группы D_2 4-го порядка. Учёт этой симметрии даёт полезный способ классификации вращат. уровней асимметричного волчка и позволяет разложить матрицу вращат. энергии на 4 блока. Гамильтонова молекулы типа

симметричного волчка, получаемый из (5) при $B_x = B_y$, инвариантен относительно операций группы D_{2d} , двух поворотов вокруг осей x и отражения на плоскости xy . Эта группа позволяет классифицировать вращат. уровни энергии молекул типа симметричного волчка по квантовому числу K . Модельная симметрия часто используется и для жёстких молекул, когда некоторые атомные группы в молекуле имеют достаточно высокую симметрию, хотя сама молекула высокой симметрии не имеет. Напр., если молекула содержит CH_3 -группу, то при изучении внутр. вращения такой группы используется точечная группа C_{3v} . В частности, туннельные группы CH_3 в приводит к известному дублетному $A - E$ расщеплению уровней по типам симметрии точечной группы C_{3v} . Более сложное кватерное туннельное расщепление уровней молекулы с двумя CH_3 -группами [напр., $(CH_3)_2CO$] классифицируется по типам симметрии прямого произведения $C_{3v} \times C_{3v}$. Лит.: Ба и Кер Ф., Симметрия молекулы и молекулярная спектроскопия, пер. с англ., М., 1981; см. также лит. при ст. Молекулярные спектры. М. Р. Алеев.

СИММЕТРИЯ СРТ — см. Теорема СРТ.

СИММЕТРИЯ $SU(2)$. В физике обычно реализуется как инвариантность относительно группы матричных преобразований над полями $\psi_i; \psi_j \rightarrow U_{ij}\psi_i$, где U_{ij} — матричное представление группы $SU(2)$. Группа $SU(2)$ — совокупность унитарных унимодулярных матриц 2-го порядка (образующая группу по отношению к обычному матричному умножению). Унитарность обеспечивает неизменность нормы двумерного комплексного вектора (столбца), к-рый преобразуется такой матрицей. Условие унимодулярности, т. е. равенство определителя единице, исключает матрицы, отличающиеся от единичной лишь домножением на числовую фазовую множитель.

Любая унитарная унимодулярная матрица U представима в виде $U = \exp(iH)$, где H — эрмитова бесследовая матрица ($H = H^\dagger, \text{Sp}H = 0$), к-рую можно выразить линейной комбинацией $n^2 - 1$ линейно независимых базисных матриц такого типа (для матриц n -го порядка). Каждая унитарная унимодулярная матрица 2-го порядка задаётся тремя вещественными параметрами, к-рые могут принимать непрерывные значения. Это значит, что $SU(2)$ — трёхпараметрич. группа Ли. $SU(2)$ — простая группа, т. е. она не содержит инвариантных подгрупп Ли.

Отметим роль условия унимодулярности. Отказавшись от него, мы получим группу $U(2)$, к-рая является прямым произведением двух друг — группы $SU(2)$ и абелевой группы Ли $U(1)$, соответствующей числовым фазовым множителям. Каждая из них является инвариантной подгруппой группы $U(2)$. Подчёркнём, что группа $SU(2)$ неабелева, т. е. два преобразования, являющихся её элементами, могут не коммутировать друг с другом.

Если матрицы, реализующие группу $SU(2)$, параметризовать в виде

$$\exp\left(i \frac{\theta}{2} \sigma_n\right) = \cos \frac{\theta}{2} + i \sigma_n \sin \frac{\theta}{2},$$

где $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ — Паули матрицы, n — вещественный единичный 3-компонентный вектор ($n^2 = 1$), то бесконечно малые преобразования порождаются генераторами группы $I_k = \sigma_k/2$. Их перестановочные соотношения $[I_j, I_k] = i\epsilon_{jkl}I_l$ совпадают с соотношениями для генераторов 3-мерной вращений группы $O(3)$. Поэтому малые преобразования группы $SU(2)$ эквивалентны преобразованиям группы $O(3)$, причём вектор n указывает направление оси вращения, а θ — угол поворота. Но соответствие групп не однозначное, поскольку в группе $O(3)$ поворот на угол $\theta = 2\pi$ считается неотличимым от тождественного преобразования, тогда как соответствующая матрица 2×2 отличается от единичной знаком. В связи с этим говорят о дву-

значных представлениях 3-мерной группы вращений. Ли алгебра генераторов группы $SU(2)$ [или $O(3)$] — единственная алгебра Ли 1-го ранга, т. е. такая, что диагонализировать один генератор (обычно I_3), невозможно, вообще говоря, диагонализировать ещё п.-л. другой генератор. Соответственно, в этой алгебре существует лишь один Казимира оператор (т. е. оператор, построенный из генераторов и коммутирующий со всеми генераторами). Он имеет вид:

$$I^2 = \sum_{k=1}^3 I_k^2.$$

Задание его числового значения достаточно для указания неприводимого представления. Возможные значения $I^2 = i(i+1)$, где i — неотрицательное целое или полуполое число.

Приложения $S. SU(2)$ в физике связаны прежде всего с представлениями группы вращений 3-мерного пространства, отвечающими подолучею спину. В частности, при спине $1/2$ получаем 2-компонентные спиноры, к-рые при вращениях преобразуются как раз унитарными унитарными матрицами 2-го порядка.

В физике элементарных частиц $S. SU(2)$ широко используется также в связи с идеей изотопической инвариантности, предложенной В. Гейзенбергом (W. Heisenberg) для описания сходства взаимодействий протона и нейтрона. Считается, что изотопич. симметрия описывает точное свойство инвариантности сильных взаимодействий, хотя получаемые из неё соотношения в действительности всегда нарушаются на уровне точности порядка одного или неск. процентов.

Предполагая, что изотопич. симметрия становится точной при отключении электродинамики, Ч. Янг (Ch. Yang) и Р. Миллс (R. Mills) предложили калибровочную теорию сильных взаимодействий, напоминающую квантовую электродинамику, но использующую себебную локальную группу $S. SU(2)$ вместо абелевой локальной группы симметрии $U(1)$. Хотя эта теория не подтверждается экспериментом (массы кварков u и d должны, видимо, различаться даже при «выключенной» электродинамике, что даёт малое, но неустраняемое нарушение изотопич. симметрии), она стимулировала чрезвычайно плодотворное исследование себебных калибровочных квантовых теорий поля, к-рые приобрели название теорий типа Янга — Миллса. С этими теориями связано ещё одно приложение группы $S. SU(2)$ к элементарным частицам. Стандартным стало совместное описание эл.-магн. и слабых взаимодействий (см. *Электрослабое взаимодействие*), основанное на калибровочной квантовой теории поля с локальной группой симметрии $SU(2) \otimes U(1)$. В этой теории симметрия спонтанно нарушается, т. е. вакуум не является инвариантным относительно точной группы симметрии лагранжиана (см. *Спонтанное нарушение симметрии*). К.-л. экспериментальных указаний на необходимость выхода за рамки такого описания электрослабых взаимодействий пока не обнаружено. Лит.: Фейнман Ф., Лессинг Ф.-мезон и нейтрино, пер. с англ., М., 1956; Элементарные частицы и компенсирующие поля. Сб. ст., пер. с англ., М., 1964; Окунь Л. В., Лептон и кварки, 2 изд., М., 1990; его же, Физика элементарных частиц, 2 изд., М., 1988. СИММЕТРИЯ $SU(3)$. В физике обычно реализуется как инвариантность относительно группы матричных преобразований над полями ψ_i : $\psi_i \rightarrow U_{ij}\psi_j$, где U_{ij} — матричное представление группы $SU(3)$. Группа $SU(3)$ — совокупность унитарных унитарных матриц 3-го порядка U (к-рая образует группу по отношению к обычному матричному умножению). Для параметризации этих матриц нужен набор из $8(3^2 - 1)$ линейно-независимых примитивных бесследовых матриц. Обычно используют Гель-Манна матрицы λ_k ($k = 1, \dots, 8$). С их помощью любая матрица из множества U задается 8 вещественными параметрами a_k в виде:

$$\exp \left[i \left(\sum_{k=1}^8 \lambda_k a_k \right) \right].$$

Т. о., группа $SU(3)$ является 8-параметрич. группой Ли. В этом представлении и при такой параметризации генераторы группы $I_k = \lambda_k/2$. Их перестановочные соотношения:

$$[I_j, I_k] = i f_{jkl} I_l,$$

где

$$f_{jkl} = (1/4) \text{Sp} \{ (\lambda_j, \lambda_k, \lambda_l) \}.$$

Как и группа симметрии $SU(2)$, группа $SU(3)$ простая. Но, в отличие от $SU(2)$, ранг группы $SU(3)$ равен двум (отметим, что существуют ещё 2 простые группы Ли 2-го ранга). Это означает, что в любом представлении можно диагонализировать по меньшей мере два генератора. В стандартном представлении матриц λ_k диагональными выбираются λ_3 и λ_8 .

2-й ранг группы $SU(3)$ имеет и др. проявления. По сравнению с группой $SU(2)$ здесь есть добавочный инвариантный «тензор». Кроме полностью антисимметричного «тензора» f_{jkl} есть другой «тензор», полностью симметричный:

$$d_{jkl} = (1/4) \text{Sp} \{ (\lambda_j, \lambda_k, \lambda_l) \}$$

(аналогичное выражение для Паули матриц σ_k обращается в нуль). Далее, в отличие от $SU(2)$, в группе $SU(3)$ имеется два Казимира оператора, коммутирующих со всеми генераторами. Один из них, квадратичный по генераторам, имеет структуру, аналогичную случаю $SU(2)$:

$$C_2 = \sum_{k=1}^8 I_k^2.$$

Другой, кубичный, не имеет аналога в $SU(2)$:

$$C_3 = \sum_{j,k,l=1}^8 d_{jkl} I_j I_k I_l.$$

Неприводимое представление $SU(3)$ задается указанием двух чисел, соответствующих значениям C_2 и C_3 в этом представлении. Часто, однако, его задают просто указанием числа элементов базиса представления: 1 для синглета, 3 для триплета, 8 для октета и т. д. Используя также обозначения типа $\bar{3}$ или 3^* для антитриплета, т. е. для представления, сопряженного к триплетному и имеющего, очевидно, столько же элементов в базисе.

Элемент базиса в определённом неприводимом представлении $SU(3)$ задается значениями двух диагональных генераторов (I_3 и I_8), тогда как в $SU(2)$ он задается одним числом (I_3). Кроме того, в $SU(3)$ возможно вырождение, т. е. одному и тому же выбору значений I_3 и I_8 могут отвечать два (или более) элемента базиса. Простейший пример этого вырождения приведён ниже в связи с унитарной симметрией.

Такое же вырождение встречается при разложении произведения двух неприводимых представлений в сумму по неприводимым представлениям (ряд Клебша — Гордана, см. *Клебша — Гордана коэффициенты*). Это разложение в группе $SU(3)$ может содержать одно и то же представление неск. раз, тогда как для группы $SU(2)$ ряд Клебша — Гордана содержит каждое представление не более одного раза. Простым примером является прямое произведение двух октетов, в разложении к-рого октетное представление появляется дважды.

В физике элементарных частиц группа $SU(3)$ появилась впервые (под назв. «унитарная симметрия») в качестве обобщения *изотопической инвариантности* в связи с моделью С. Сакаги (Sh. Sakata, 1956), в к-рой все адроны считались составленными из трёх основных — протона, нейтрона и Λ -гиперона. Хотя модель Сакаги отвергнута экспериментом, унитарная симметрия сохранилась в виде «восьмеричного подхода» М. Гелл-Манна (M. Gell-Mann) и Ю. Неэмана (Y. Neeman, 1964), в к-ром все адроны группируются в унитарные мультиплеты всего трёх типов: 1, 8, 10 (10 для античастиц). Примером является барионный октет, включающий протон, нейтрон, три Σ -гиперона, Λ -гиперон и два Ξ -гиперона. Отметим вырождение, о к-ром говорилось выше: октет содержит два элемента $I_3 = I_8 = 0$. В барионном октете это Σ^0 и Λ . Вырождение снималось обычно, выбирая определённое значение *изотопического спина*, хотя с чисто групповой точки зрения возможны др. варианты.

Ограниченный набор типов унитарных мультиплетов являлся одной из основ феноменологич. модели кварков, составляющей мезоны из кварка и антикварка, а барионы из трёх кварков. Найдены убедительные свидетельства существования бескварковых мезонов (*мезобозон*), но не доказано существование др. спектров к-рых требовала бы дополнительных кварк-антикварковых пар.

Унитарная симметрия осуществляется с худшей точностью, чем изотопическая. Тем не менее, даже с учётом её нарушения, удаётся получить ряд интересных соотношений между др. величинами. Наиб. известным соотношением такого рода является ф-ла масс Гелл-Манна — Окубо (см. *Гипероны*), к-рая позволила Гелл-Манну предсказать существование и массу Ω -гиперона.

На кварковом уровне унитарная симметрия соответствует объединению трёх кварков u, d, s в унитарный триплет. Все остальные кварки считаются синглетами. В связи с такой структурой унитарной симметрии её часто называют флейворной $SU(3)$ [обозначение $SU(3)_f$], чтобы отличить от др. превращений группы $SU(3)$ в физике частиц (флейвор — в переводе с англ. *аромат*). При кварковом подходе нарушение унитарной симметрии порождается заметным отличием массы s -кварка от масс u, d -кварков. Возможность же объединения u, d, s -кварков в один триплет связана с тем, что различие их масс между собой мало по сравнению с их отличием от массы любого другого кварка.

Ещё одно чрезвычайно важное приложение группы $SU(3)$ к физике адронов — это цветовая симметрия. Установлено, что каждый кварк имеет три возможных состояния, различающихся по квантовому числу, названному цветом. Изменение цветового состояния оставляет инвариантным лагранжиан, что порождает цветовую группу $SU(3)$ [обозначение $SU(3)_c$]. В отличие от флейворной цветовой симметрия локальная, т. е. преобразование цветового состояния можно производить независимо в разных пространственно-временных точках. С этим связано существование нового поля, глюонного (см. *Глюоны*), имеющего восемь цветовых состояний. Взаимодействие кварков с глюонным полем является «микроскопической» основой *сильных взаимодействий*. Оно описывается *квантовой теорией гравитационной* — калибровочной квантовой теорией поля типа Янга — Миллса с локальной группой $SU(3)$. Ещё одно важное отличие цветовой симметрии от флейворной в том, что $SU(3)_c$ является точной симметрией, к-рую не нарушают никакие известные в настоящее время взаимодействия [в отличие от симметрий, основанных на группе $SU(2)$].

СИММЕТРИЯ $U(1)$. В квантовой физике обычно реализуется как инвариантность относительно группы $U(1)$ фазовых преобразований ψ -ф-ий поля

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi, \quad \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}e^{-i\alpha}, \quad (*)$$

где q — заряд поля [в общем случае генератор соответствующей группы $U(1)$], α — параметр преобразования (фаза), чёрточка означает комплексное сопряжение [1]. $U(1)$ — непрерывная компактная группа. Её образуют все комплексные числа, равные по абс. величине единице. Множество таких чисел замкнуто относительно операции умножения и удовлетворяет остальным требованиям, входящим в определение группы. Группа $U(1)$ служит накрывающей для группы двумерных вращений, и все представления последней являются одновременно и представлениями группы $U(1)$.

Согласно *Нётер теореме*, из инвариантности лагранжиана относительно преобразований типа (*) следует сохранение соответствующего нётеровского тока. В стандартной модели (СМ) *сильного взаимодействия* и *электрослабого взаимодействия* именно таким образом возникает сохранение барионного и лептонного чисел. Если фаза α не зависит от пространственно-временной координаты, $S. U(1)$ наз. *глобальной*, в противном случае — *локальной*. Простейшим примером теории с локальной $S. U(1)$ является электродинамика (см. *Калибровочные поля*).

Ряд нетривиальных эффектов связан с глобальными $S. U(1)$ стандартной модели, к-рые становятся аномальными после учёта квантовых поправок (см. *Аномалии в квантовой теории поля*). В *квантовой гравитационной* (КХД) наб. интерес представляет группа $U(1)_A$ синглетных по ароматам аксиальных преобразований (генератором к-рых является аксиальный заряд) кварковых полей. Лагранжиан КХД в случае безмассовых кварков инвариантен относительно таких преобразований. Но симметрия нарушается спонтанно (см. *Спонтанное нарушение симметрии*) из-за образования кварк-антикваркового конденсата [2]. В соответствии с *Голдстоуна теоремой* такое нарушение $S. U(1)$ должно сопровождаться появлением в спектре фаз. частиц (в пределе нулевой массы кварков) строго безмассового *голдстоуновского бозона*. $U(1)$ -проблема [С. Вайнберг (S. Weinberg), 1975] состоит в том, что среди известных адронов нет лёгкого псевдоскалярного бозона, соответствующего спонтанно-нарушенной $S. U(1)_A$, а в основном синглетной по глобальной группе *симметрии* $SU(3)$ η -мезон (к-рый должен был рассматриваться в качестве голдстоуновской частицы) является тяжёлым. Осн. идея решения $U(1)$ -проблемы была сформулирована в работах Г. ван Хофта (G. 't Hooft, 1976), Э. Виттона (E. Witten, 1979) и Дж. Венециано (G. Veneziano, 1979) и состоит в том, что вследствие киральной аномалии сохраняющийся синглетный аксиальный ток приобретает дивергенцию, пропорциональную плотности *топологического заряда* Q глюонного поля. Поэтому теорема Голдстоуна не применима к аномально нарушенной $S. U(1)_A$ и масса η -мезона даже в киральном пределе (т. е. при нулевых массах кварков) остаётся отличной от нуля. Она зависит от величины *корреляционной функции* (коррелятора) плотности топологич. зарядов $\langle QQ \rangle$. Этот коррелятор обращается в нуль во всех порядках теории возмущений, и его отличие от нуля, необходимое для решения $U(1)$ -проблемы, указывает на то, что основное состояние в КХД не может быть описано в рамках *возмущенной теории*.

Потенциальная энергия в КХД нееродически зависит от калибровочно-неинвариантной обобщённой координаты

$$X = \int d^3x K_0(x),$$

где K_0 — нулевая компонента глюонного тока K_μ , дивергенция к-рого равна плотности топологич. заря-

Лит.: Элементарные частицы и компенсирующие поля. Сб. ст., пер. с англ., М., 1964; Окубо и Л. Б. Физика элементарных частиц, 2 изд., М., 1988; Вольф и М. Б., Тейлор — Иерархия и К. А., Теория калибровочных взаимодействий элементарных частиц, М., 1984. Я. И. Акимов.

да. При нетривиальном калибровочном преобразовании координата X меняется на целое число, равное топологии заряда преобразования. Зависимость волновой ф-ции основного состояния от координаты X имеет характерный вид из физики твёрдого тела блоховский вид (см. *Блоховские электроны*) и характеризуется величиной *квазиимпульса* θ . Физ. эффекты, связанные с параметром θ , удобно изучать считая, что к обычному лагранжиану глущих полей добавлен новый член θQ . Включение θ -члена в лагранжиан означает, вообще говоря, сильное нарушение P -и CP -инвариантности в сильных взаимодействиях [3]. Но эксперименты по проверке CP -инвариантности, в частности измерение электрич. дипольного момента *нейтрона*, дают жесткое ограничение на величину θ -члена: $|\theta| < 10^{-9}$. В КХД можно считать затронутой параметр θ в лагранжиане очень малым, но наличие столь малого числа является неестественным и требует объяснения. Энергия основного состояния в КХД зависит от аначения θ и достигает минимума при $\theta = 0$. Осн. идея решения проблемы сильного нарушения CP -инвариантности состоит в расширении СМ, чтобы обеспечить системе возможность перейти в состояние с наименьшей энергией. Р. Печчи и Х. Куинн (Р. Peccei, H. Quinn, 1977) предложили ввести в СМ новую глобальную аксиальную С. $U(1)_{PQ}$, такую, что лагранжиан остаётся инвариантным при одновремен. аксиальном фазовом преобразовании кварковых полей и фазовом преобразовании *Хиггса полей*. В полной СМ симметрия $U(1)_{PQ}$ нарушена аксиальной аномалией, и фаза $U(1)_{PQ}$ -преобразования становится аддитивной добавкой к θ . После спонтанного нарушения симметрии в хиггсовском секторе (в части лагранжиана, содержащей только поля Хиггса) фаза превращается в динамич. степень свободы и её вакуумное среднее определяется из условия минимума энергии, что приводит к обращению в нуль эффективного θ -члена и решает проблему сильного нарушения CP -инвариантности.

Рассмотрим те глобальные С. $U(1)$, судьба к-рых зависит от свойств электрослабого взаимодействия [4]. Сохранение *барионного числа* и *лептонного числа* в СМ гарантировано инвариантностью классич. лагранжиана относительно двух независимых групп $U(1)$ фазовых преобразований. С учётом квантовых поправок соответствующие этим группам барионный и лептонный токи становятся аномальными и приобретают дивергенции, пропорциональные плотности топологич. заряда электрослабых калибровочных бозонов. Потенциальная энергия в теории с глобальными С. $U(1)$ периодична, как и в КХД, но обобщённой координате X (она, конечно, построена теперь из электрослабых калибровочных полей), причём минимумы разделены барьерами высотой порядка $kM_W/\alpha_W \approx 10$ ТэВ (M_W — масса W -бозона, α_W — константа электрослабого взаимодействия). Из выражений для аномальных дивергенций барионного и лептонного токов видно, что всякий подбарьерный переход сопровождается изменением барионного B и лептонного L чисел $\Delta B = \Delta L = -3\Delta X$, а разность $B - L$ сохраняется. Она задана, что вероятность таких процессов подавлена подбарьерным фактором $\exp(-4\pi/\alpha_W) \sim 10^{-170}$ (Г'Хоофт, 1976).

Интерес к несохранению барионного числа в СМ возрос после работы В. А. Кузьмина, В. А. Рубакова и М. Е. Шапошников (1985), к-рые отметили, что при высокой темп-ре, превышающей (в энергетич. единицах) высоту потенциального барьера, переходы с изменением барионного числа не подавлены. Такие процессы учитывают при решении вопроса о происхождении *барионной асимметрии Вселенной*.

Лит.: 1) Окуи и Л. Б., *Лептоны и кварки*, 2 изд., М., 1990; 2) Идуррай Ф., *Квантовая хромодинамика*, пер. с англ., М., 1986; 3) Ансельды А. А., Урвадзе Н. Г., Легкие и бесмассовые хиггсовские частицы, в сб.: *Физика элементарных частиц*, т. 1, 1985; 4) Дьяконов Л. И., Петров В. Ю., *Несохранение барионного заряда в процессах при высокой энергии*, в сб.: *Физика элементарных частиц*, т. 1, 1991.

М. И. Эйбес.

СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ ГРУППА (от лат. simplex — простой) — группа линейных преобразований конечномерного *векторного пространства* (вещественного или комплексного), сохраняющих косокалярное произведение, т. е. невырожденную кососимметричную (в физ. приложениях чаще употребляется термин «антисимметричная») билинейную форму. Пространство, снабжённое кососкалярным произведением, наз. симплектическим. Роль С. г. в симплектич. пространстве аналогична роли ортогональной группы в евклидовом пространстве.

Примеры. 1) Кососкалярное произведение на плоскости с координатами p, q — это форма площади $p \wedge q$. Паре векторов она сопоставляет ориентированную площадь натянутого на них параллелограмма и меняет знак при перестановке векторов. Напр., кососкалярное произведение (u, w) пары векторов в декартовых координатах u_1, u_2 и w_1, w_2 можно записать в виде: $(u, w) = u_1 w_2 - u_2 w_1$. С. г. плоскости изоморфна группе 2×2 — матриц с определителем 1.

2) Прямая сумма n симплектич. плоскостей несёт кососкалярное произведение $p_1 \wedge q_1 + \dots + p_n \wedge q_n$, носящее паре векторов сумму площадей проекций на координатные плоскости натянутого на эти векторы параллелограмма. С. г. содержится в группе линейных преобразований, сохраняющих объём $p_1 \wedge q_1 \wedge \dots \wedge p_n \wedge q_n$.

3) Мнимая часть невырожденной эрмитовой формы в n -мерном комплексном пространстве, рассматриваемом как $2n$ -мерное вещественное, является кососкалярным произведением. В координатах $z_k = p_k + iq_k$ эрмитова

форма $\sum_{k=1}^n p_k \bar{z}_k$ имеет мнимую часть $-\sum_{k=1}^n p_k \wedge q_k$. С. г. со-

держит унитарную группу — группу комплексных линейных преобразований, сохраняющих эту эрмитову форму. Унитарная группа — максимальная компактная подгруппа в С. г.

Изучение симплектич. пространства упрощается благодаря теореме Дарбу — Фробениуса, согласно к-рой симплектич. пространство $2n$ -мерно, а два таких пространства одной размерности симплектически изоморфны.

Косоортогональность. Два вектора наз. косоортогональными, если их кососкалярное произведение — нуль. Вектор, косоортогональный всему пространству, — нулевой. В этом состоит определение невырожденности кососкалярного произведения. Каждый вектор себе косоортогонален (следствие кососимметричности). Косоортогональное дополнение прямой — гиперплоскость, содержащая эту прямую. Обратн., косоортогональное дополнение гиперплоскости — прямая в ней. Вообще косоортогональное дополнение подпространства имеет дополнит. размерность. Два подпространства одинаковой размерности переводятся друг в друга преобразованием из С. г., если и только если совпадают размерности их пересечений со своими косоортогональными дополнениями. В частности, любая прямая (гиперплоскость) переводится в любую другую. Т. о., геометрия симплектич. пространства во многом определяется структурой С. г.

С. г. $2n$ -мерного симплектич. пространства — это простая связанная группа Ли, обозначаемая $Sp(2n, \mathbb{R})$ [в комплексном случае $Sp(2n, \mathbb{C})$]. Её размерность $(2n + 1)n$. Ли алгебра этой группы изоморфна алгебре Ли однородных многоуголов стени 2 от переменных $(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n)$ с Пуассона скобкой в качестве коммутатора:

$$[f, g] = f p g q - f q g p = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} - \frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} \right).$$

По этой причине изучение С. г. равносильно до нек-рой степени изучению линейных гамильтоновых систем дифференциальных ур-ний.

А. В. Гузельман.

СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА — замкнутая невырожденная дифференциальная форма степени 2. Многообразие, снабжённое С. с., наз. *симплектическим многообразием*. В каждом касательном пространстве С. с. задаёт кососкалярное произведение и е (см. в ст. Симплектическая группа). Кососкалярное произведение (v, w) пары векторов можно принять за определение площади натянутого на них параллелограмма. Поэтому на симплектич. многообразии определена площадь 2-мерных ориентированных поверхностей. Условие замкнутости С. с. связывает кососкалярные произведения в соседних касательных пространствах таким образом, что (ориентированная) площадь (малой) замкнутой поверхности нулевая. Условие невырожденности кососкалярного произведения позволяет отождествить на симплектич. многообразии векторы и ковекторы (линейные ф-ции от векторов): $v \leftrightarrow \langle v, \cdot \rangle$. Оба условия вместе делают локальную геометрию С. с. универсальной (теорема Дарбу): в окрестности любой точки существуют координаты $(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n)$, называемые координатами Дарбу, в к-рых С. с. принимает вид $dp_1 \wedge dq_1 + \dots + dp_n \wedge dq_n$. Для сравнения заметим, что в римановой геометрии риманова метрика $\sum g_{ij}(x) dx_i dx_j$ (скалярное произведение в касательных пространствах) приводится в подходящих локальных координатах к виду $(dx_i)^2 + \dots + (dx_n)^2$ лишь с точностью до членов 2-го порядка малости: $g_{ij}(x) = \delta_{ij} + O(|x|^2)$ (последние определяют кривизну риманова многообразия в данной точке).

С. с. естественным образом возникает в классич. механике, а также в комплексной геометрии. Пусть M^n — n -мерное комплексное многообразие, G — эрмитова метрика на нём (т. е. эрмитово скалярное произведение в касательных пространствах). Если рассмотреть M как $2n$ -мерное вещественное многообразие, то $g = \text{Re} G$ задаёт евклидово скалярное, а $\omega = \text{Im} G$ — кососкалярное произведение в касательных пространствах. Эрмитова метрика G на калеровой структуре τ у τ ро θ , если θ является С. с., т. е. замкнута: $d\theta = 0$. Последнее условие необходимо и достаточно для того, чтобы эрмитова метрика G в подходящих локальных комплексных координатах приводилась к виду $\sum |dz_i|^2 + O(|z|^2)$.

Примеры. 1) Комплексное проективное пространство CP^n по определению состоит из всех комплексных одномерных подпространств в C^{n+1} . Касательное пространство $T_x CP^n$ отождествляется с эрмитово-ортогональной гиперплоскостью к прямой x относительно эрмитовой формы $\sum_k \bar{w}_k w_k$ в C^{n+1} . Форма $\sum_k \bar{w}_k w_k$ рассматриваемая на этой гиперплоскости, задаёт эрмитову форму в касательном пространстве к CP^n в точке x . Такие формы, определённые во всех точках CP^n , задают эрмитову метрику на CP^n . Эта метрика калерова и называется метрикой Фубини — Штуди.

2) Комплексное алгебраич. многообразие — это комплексное подмногообразие в комплексном проективном пространстве. Ограничение метрики Фубини — Штуди на такое подмногообразие наделяет его калеровой структурой. В частности, алгебраич. многообразия обладают С. с. Более общо, комплексное подмногообразие калерова многообразия само калерова.

3) Гиперкалерова структура (на $4l$ -мерном вещественном многообразии) состоит из трёх комплексных структур I, J, K , удовлетворяющих соотношениям для образующих алгебры кватернионов $[I, J]$ в такой метрике Дирака $\langle \cdot, \cdot \rangle$, что соответствующие кососкалярные произведения $\omega_I, \omega_J, \omega_K$ замкнуты. Т. о., касательные пространства к гиперкалеровому многообразию несут структуру кватернионного пространства, а само многообразие — риманову метрику, согласованную с тремя вещественными С. с., или в комплексной интер-

претации — три калерова структуры Z_I, Z_J, Z_K и три комплексные С. с. W_I, W_J, W_K .

Отметим, что риманова метрика на 4 -мерном ($n = 1$) гиперкалеровом многообразии имеет антиевклидову форму кривизны и автоматическое удовлетворяет ур-нию Эйнштейна (см. Тяготение). Само гиперкалеровое многообразие наз. в этом случае гравитат. *истантоном*, чем подчёркивается, что речь идёт не о метрике Минковского, а о евклидовой версии общей теории относительности.

Лит. см. при ст. Симплектическое многообразие.

СИМПЛЕКТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ — многообразие, снабжённое симплектической структурой. С. м. играют фундам. роль в классич., статистич. и квантовой механике, поскольку симплектич. структура оказывается естественной геом. структурой фазовых пространств гамильтоновых систем. Все атрибуты гамильтонова формализма переносятся на любое С. м., а координаты Дарбу являются канонич. переменными.

Примеры. 1) Фазовое пространство. Пусть X — конфигурац. пространство механич. системы, $M = T^*X$ — его касательное расслоение. Локальные координаты в M — это обобщённые координаты (q_1, \dots, q_n) точки q на X и обобщённые импульсы (p_1, \dots, p_n) (координаты ковектора p из касательного пространства в точке q). Дифференциальная 1-форма $\alpha = \sum p_i dq_i$ наз. формой Лиувилля и допускает инвариантное определение: её значение на касательном векторе v к M в точке (p, q) задаётся как значение ковектора p на образе вектора v при проекции $T^*X \rightarrow X$. Симплектич. структура ω на M определяется как дифференциал формы Лиувилля: $\omega = dx = \sum dp_i \wedge dq_i$.

2) Картина Шрёдингера — подход, основанный на гамильтоновом векторном поле. Гамильтониан H (ф-ция на С. м.) задаёт векторное поле v_H по правилу: отвечающее v_H поле ковекторов должно совпадать с дифференциалом dH ф-ции Гамильтона. Движение фазовой точки со скоростью v_H описывается системой дифференциальных ур-ний, к-рая в координатах Дарбу принимает вид ур-ний Гамильтона:

$$\dot{p} = -H_q, \quad \dot{q} = H_p.$$

3) Картина Гейзенберга — подход, основанный на алгебре ф-ций. Ф-ла $\{F, G\} = (v_F, v_G)$ задаёт Пуассона скобку в пространстве ф-ций на С. м. В координатах Дарбу $\{F, G\} = F_q G_p - F_p G_q$. Геом. интерпретация функции $\{H, F\}$ как производной ф-ции F вдоль потока поля v_H означает, что картина Шрёдингера эквивалентна картине Гейзенберга: физ. величины (ф-ция на фазовом пространстве) меняются во времени согласно ур-нию $\dot{F} = \{H, F\}$. Из этой эквивалентности вытекают осн. свойства законов сохранения: сохранение энергии ($\{H, H\} = 0$); *Итер теорема* — если поток поля v_F сохраняет ф-цию Гамильтона H , то F — первый интеграл потока v_H ($\{H, F\} = 0 \Rightarrow \{H, F\} = 0$); теорема Пуассона — скобка Пуассона $\{F, G\}$ первых интегралов снова первый интеграл (это следует из тождества Якоби).

Если же в пространстве ф-ций на многообразии задана скобка Пуассона, то многообразие разбивается в объединение С. м., называемых симплектич. слоями. Это один из способов строить примеры С. м., по-полная, в частности, запас физ. моделей.

4) Статистич. механика. Поток векторного поля на С. м. сохраняет симплектич. структуру ω , если и только если это поле локально гамильтоново. В частности, его поток сохраняет фазовый объём $\omega^n = \omega \wedge \dots \wedge \omega$ (n — число степеней свободы). Этот факт лежит в основе статистич. механики. Эволюция фазовой плотности $\rho^{\text{ф}}$ под действием потока поля v_H удовлетворяет ур-нию Лиувилля, $\dot{\rho} = \{ \rho, H \}$. Отсюда вытекает, напр., стацיו-

нажность распределения Гиббса $\exp(-\beta H)\omega^n$. В координатах Дарбу

$$\omega^n = \prod dp_i \wedge dq_1 \dots \wedge dp_n \wedge dq_n.$$

5) Классич. подход к спину. Векторное произведение в 3-мерном евклидовом пространстве порождает скобку Пуассона ф-ций на нбм. Симплектик. слои в данном примере — концентрич. сферы, снабженные элементом площади. *Вращающей группой* сохраняющей площадь и потому действующей на сфере потоками гамильтоновых векторных полей. Гамильтонианы действия — линейные ф-ции в пространстве. Квантование этого действия возможно лишь в сферах целочисленной площади (в единицах \hbar) и приводит к непротиворечивым *представлениям группы вращений* — как векторным, так и «спинорным».

6) Принципы наименьшего действия. Двум траекториям в С. м. с общими концами сопоставим симплектик. площадь соединяющей их 2-мерной пленки. Эта площадь по существу не зависит от пленки (замкнутость симплектик. структуры!) и определяет поэтому функционал, называемый действием, на пространстве таких траекторий (он определен с точностью до постоянного слагаемого). Экстремали функционала действия в классе траекторий на поверхности фиксиров. уровня гамильтониана H суть в точности траектории поля v_H (следствие координатности поля v_H к уровням $H = \text{const}$). Этот геом. вариационный принцип — прототип всех вариационных принципов матем. физики.

Имеется и обратная связь — пространство экстремальной вариации, задачи, как правило, несут естественную симплектик. структуру. Последнее обстоятельство лежит в основе перехода от *лагранжева формализма* к гамильтонову, а также даёт ещё один способ пополнить запас примеров С. м.

7) Теория Дирака. К гамильтонову формализму со связями обычно приходят, отправляясь от *лагранжева*, вырожденного по скоростям (определятель матрицы производных лагранжиана по скоростям равен нулю). Требование непротиворечивости динамики, у-рий означает, что подмногообразие связей F в С. м. M инволютивно: пространство F связей (ф-ций на M , нулевых на F) замкнуто относительно скобки Пуассона ($\{J, J\} \subset J$). Поток векторного поля, отвечающего гамильтониану H , сохраняет F , если $\{H, J\} \subset J$. Все такие гамильтонианы образуют замкнутое относительно скобки Пуассона алгебру A . Физ. величины — это элементы фактор-алгебры A/J . Их можно воспринимать как ф-ции на физ. фазовом пространстве $B = \text{базе}$ некоего расслоения $F \rightarrow B$. Скобка Пуассона в A/J наделяет B симплектик. структурой. Эта конструкция используется в калибровочно инвариантных теориях (см. *Калибровочная инвариантность*), где вместо проекции из F в B обычно фиксируют «калибровку», т. е. сечение расслоения $F \rightarrow B$ в качестве физ. фазового пространства.

8) У-рии Эйлера (для твёрдого тела). Если действие группы Ли G на С. м. M сохраняет симплектик. структуру, то алгебра \mathfrak{G} -инвариантных ф-ций на M замкнута относительно скобки Пуассона. Рассматривая \mathfrak{A} как алгебру ф-ций на многообразии A , получаем расслоение A на симплектик. слои, а также проекцию $M \rightarrow A$, сохраняющую скобки Пуассона. На этой конструкции основано понижение порядка симметричных гамильтоновых систем: траектории на M G -инвариантного поля v_H проектируются в траектории гамильтонова потока на слоях в A с гамильтонианом $H \in \mathfrak{A}$. Таким способом возникает, напр., у-рии Эйлера, $\dot{m} = [m\dot{\theta}]$, описывающее эволюцию вектора момента импульса во внутр. координатах твёрдого тела при его свободном вращении. Здесь G — группа вращений; $M = T^*G$ — её кокасательное расслоение, действие G на M задается сдвигами на группе, а проекция $M \rightarrow A = M/G$ совпадает с отображением момента $T^*G \rightarrow \mathfrak{A}^*$ в двой-

ственное пространство алгебры Ли \mathfrak{G} (см. С. Скобка Пуассона в \mathfrak{A} порождается коммутатором в \mathfrak{G} . Симплектик. слои в \mathfrak{A}^* — это орбиты коприсоединённого представления группы G . Тензор инерции тела интерпретируется как оператор $Q: \mathfrak{G} \rightarrow \mathfrak{G}^*$ и устанавливает связь вектора угл. скорости $\omega \in \mathfrak{G}$ с вектором момента $\Pi = Q\omega$ и задаёт на \mathfrak{A}^* квадратичный гамильтониан $H = \langle \Pi | Q^{-1} \Pi \rangle$).

Аналогичная конструкция с группой G сохраняющих объём диффеоморфизмов приводит к у-рию вихря $d(\text{rot}v)/dt = [v, \text{rot}v]$ в теории свободного течения идеальной жидкости, где роль порождающего гамильтониана оператора инерции выполняет ротор.

Отображение момента $V^*G \rightarrow \mathfrak{G}^*$ играет фундаментальную роль в современной теории вполне интегрируемых систем. В частности, один из подходов к интегрированию *Кортвега — де Фриза уравнения* основан на его интерпретации как у-рия Эйлера на орбите коприсоединённого представления в двойственном пространстве алгебры Вирасоро.

Лит.: Арнольд В. И., Математические методы классической механики, 3 изд., М., 1988; Арнольд В. И., Глиен и таль А. В., Симплектическая геометрия, в кн.: Итоги науки и техники. Сер. Современное проблемы математики. Фундаментальные направления, т. 4, М., 1985, с. 5; Кириллов А. А., Геометрическое квантование, там же, с. 141.

А. Б. Гузентал

СИГЛЕТЫ (от англ. single — одиночный) — одиночные спектральные линии в атомных спектрах, соответствующие разрешённым квантовым переходам между сиглетными уровнями энергии (см. *Мультиплетность*). Сиглетные линии составляют, напр., гл. спектральную серию атомов щёлочноземельных элементов.

СИГНОНИЯ кристаллическая — подразделение кристаллов по симметрии формы их *элементарной ячейки* (элементарного параллелепипеда повторяемости), или, что то же самое, по точечной симметрии узлов кристаллич. решётки. С. характеризуется определёнными соотношениями между периодами элементарной ячейки a, b, c и углами между ними α, β, γ (см. *Симметрия кристаллов*). Всего существует 7 С. — триклинная, моноклинная, ромбическая, тетрагональная, тригональная, гексагональная, кубическая.

В. Н. Вайнштейн

СИНГУЛЯРНОСТЬ КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ (от лат. singularis — отдельный, особый) — состояние нашей Вселенной в определённый момент времени в прошлом, когда плотность энергии материи ρ и кривизна пространства-времени были очень велики — порядка планковских значений ($\rho \sim \rho_{\text{пл}} = c^2/G^2 \hbar \sim 10^{114}$ эрг/см³, $|R_{iklm}| \sim c^4/G^2 \hbar^2 \sim 10^{121}$ см⁻⁴, где R_{iklm} — кривизны тензор) — физическая сингулярность, или даже бесконечны — математическая С. к. Это состояние, вместе с последующим этапом эволюции Вселенной, пока плотность энергии материи оставалась высокой, называют также *Большим Взрывом*.

Тот факт, что Вселенная в прошлом проходила через состояние с темп-рой $T \sim 10^9$ К, следует из существования в настоящее время изотропного *микроволнового фонового излучения* (реликтового излучения) со строго тепловым (планковским) спектром, а наличие темп-ры $T \sim 10^9 - 10^{10}$ К (100 кэВ — 1 МэВ) в ещё более ранний момент — из теории космологии, *нуклеосинтеза*, дающей правильные значения для наблюдаемых концентраций дейтерия, гелия-3, гелия-4 и лития-7. Дальнейшая экстраполяция в прошлое, в область более высоких энергий, плотностей энергии и темп-ры, следует из у-рий классич. теории гравитации — общей теории относительности (см. *Тяготение*). Согласно этой теории, С. к. есть частный случай сингулярности (особенности), возникающих в решениях у-рий Эйнштейна, а существование матем. С. к. неизбежно следует из факта изотропного расширения наблюдаемой части Вселенной в настоящее время и существования релик-

тового излучения. Для наиб. вероятной модели Вселенной, в к-рой плотность вещества равна критической (см. *Космология*), а давление вещества много меньше его плотности энергии, С. к. имела место $2/(3H) = 13 (H/50 \text{ км/с.Мпк})^{-1}$ млрд. лет назад (H — *Хаббля постоянная*). При наличии положительной космологич. постоянной или в случае отрицательности кривизны трёхмерного пространства возраст Вселенной может быть больше.

Сингулярности пространства-времени вообще и С. к. в частности являются естеств. границой применимости классич. теории гравитации. Эволюция Вселенной до выхода из физ. С. к. (а также, возможно, нек-рое время после) должна следовать из к.-л. квантового обобщения теории гравитации (см. *Квантовая теория гравитации*). В частности, в общей теории относительности начальные условия в момент матем. С. к. для малых неоднородных возмущений метрики пространства-времени модели Фридмана, описывающей однородную изотропную Вселенную, могут быть произвольными функциями пространственных координат. Более фундаментальная квантовая теория, позволяющая рассчитать структуру физ. С. к., должна давать конкретные предсказания для этих начальных условий, к-рые могут быть проверены с помощью наблюдательных данных о крупномасштабной структуре Вселенной, анизотропии темп-ры реликтового эл.-магн. излучения, спектре и статистике реликтового фона *гравитационных волн* в настоящее время. Напр., такого рода предсказания следуют из модели Вселенной с де-ситтеровской (инфляционной) стадией вблизи С. к. (см. *Первичные флуктуации* в ранней Вселенной). А. А. Старобинский.

СИНГУЛЯРНЫЕ ФУНКЦИИ в квантовой теории и поля — релятивистски-инвариантные функции, тесно связанные с квантованием волновых полей, имеющие сингулярное поведение в окрестности светового конуса и начала координат. В первую очередь к С. ф. относятся *перестановочные функции*, стоящие в правых частях коммутат. соотношений в x -представлении. Простейшей из них является перестановочная функция скалярного поля φ

$$\varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x) = \frac{1}{i} D(x-y) -$$

т. е. функция Паули — Йордана, к-рая явно выражается через функцию Бесселя J_1 (см. *Цилиндрические функции*), делая функцию Дирака δ и известные разрывные функции

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } x > 0; \\ 0 & \text{при } x < 0; \end{cases} \quad \varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } x > 0; \\ -1 & \text{при } x < 0; \end{cases}$$

следующим образом:

$$D(x) = \frac{1}{2\pi} \varepsilon(x^0) \delta(x^2) - \frac{m}{4\pi\sqrt{x^2}} \varepsilon(x^0) \theta(x^2) J_1(m\sqrt{x^2}). \quad (1)$$

Здесь $x^2 = x^2 - x^2 -$ квадрат четырёхмерного интервала, $x = (x_0, \mathbf{x})$, $y = (y_0, \mathbf{y})$ — точки пространства-времени, m — масса кванта поля (используется система единиц, в к-рой $\hbar = c = 1$). Как видно, в окрестности светового конуса $D(x)$ имеет особенность $\varepsilon(x^0)\delta(x^2)$ и $\varepsilon(x^0)\theta(x^2)$.

Перестановочные функции полей с ненулевым спином выражаются через линейные комбинации $D(x)$ и её производных. Напр., перестановочная функция Дирака поля $S(x)$ связана с D соотношением

$$S(x) = (i\gamma^0 \partial_x + m) D(x), \quad (2)$$

где $\partial_x = \partial/\partial x^\alpha$ и γ^i ($i = 0, 1, 2, 3$) — Дирака матрицы. Перестановочные функции являются решениями соответствующих полевых ур-ний. Функция Паули — Йордана удовлетворяет *Клейна — Гордона уравнению* (а также вытекающему из коммутат. соотношения ус-

ловию антисимметрии), а функция $S(x)$ — Дирака уравнению.

Помимо перестановочных С. ф. важную роль играют *Грина функции*, т. е. решения соответствующих неоднородных ур-ний, в правой части к-рых стоит 4-мерная δ -функция. К ним принадлежат запаздывающие, опережающие, а также анимажные контр. место в квантовополевых расчётах причинные функции Грина (*пропагаторы*). Напр., причина С. ф. скалярного поля D^c , определённая через вакуумное среднее от хронологического произведения операторов

$$D^c(x-y) = i \langle T \varphi(x) \varphi(y) \rangle_0,$$

удовлетворяет неоднородному ур-нию

$$(\square - m^2) D^c(x) = -\delta^4(x),$$

может быть представлена в виде 4-многого интеграла Фурье

$$D^c(x) = (2\pi)^{-4} \int \frac{\exp i k x}{m^2 - k^2 - i\epsilon} dk, \quad \epsilon \rightarrow +0$$

и в явном виде выражена через функции Бесселя J_1 , N_1 , K_1 , а также $\theta(x^0)$ и $\delta(x^2)$. В окрестности светового конуса она имеет следующее поведение:

$$D^c(x) \approx \frac{1}{4\pi} \delta(x^2) + \frac{1}{4\pi x^2} + \frac{i\pi^2}{8\pi^2} \ln \frac{m\sqrt{x^2}}{2} - \frac{m^2}{16\pi} \theta(x^2). \quad (3)$$

Причинные функции полей со спином выражаются через D^c и её производные линейными соотношениями, подобными (2).

В квантовополевых расчётах приходится иметь дело с произведениями и степенями пропагаторов разл. полей. Напр., однопетлевой диаграмме *поляризации вакуума* в x -представлении соответствует произведение двух причинных функций поля Дирака:

$$\gamma^i S^c(x-y) \gamma_j S^c(y-z),$$

а в окрестности светового конуса при $(x-y)^2 \approx 0$ — производные выражений (3) и их первых производных. С матем. точки зрения входящие в (3) сингулярные объекты представляют собой *обобщённые функции*.

Теория С. ф. квантовой теории поля была разработана Н. Н. Боголюбовым в нач. 1950-х гг. Она явилась основой оригинальной схемы устранения УФ-расходимостей, не использующей *контрактное и перенормировок*.

Лит.: Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантовых полей, 4 изд., М., 1984, т. 3; и т. ж., Квантовые поля, М., 1980.

СИНЕРГЕТИКА (от греч. synergētikós — совместный, согласованно действующий) — направление в науке, связанное с изучением закономерностей пространственно-временного упорядочения в разнообразных системах. Термин «С.», введённый Г. Ханеном (H. Haken) в нач. 1970-х гг., отражает тот факт, что процессы упорядочения в макроскопич. системе возникают благодаря взаимодействию большого числа элементарных подсистем. Возникновение С. как самостоят. направления связано с тем, что поведение разнообразных физ., хим., биол. и др. систем описывается сложными матем. моделями и для таких систем характерны одни и те же явления *самоорганизации*. Это позволяет широко использовать результаты исследования одних объектов при анализе других. Напр., модель А. Н. Колмогорова, И. Г. Петровского, Н. С. Пискунова, исследованная в 1937 в связи с биол. проблемой распространения популяций на нек-рой территории, была использована при анализе закономерностей фронта горения, распространения возмущения в сердечной ткани и др.

Осн. понятия С.: *диссипативная структура* (пространственно упорядоченное состояние системы, обычно с симметрией, более низкой, чем симметрия исходного состояния), волна и перекрестки и я (бегущий фронт фазового перехода), ведущий и пассивный (локализованный) автогенератор бегущих импульсов, вра-

щадящая спиральная структура, называемая в С. ревербератором, и др. Эти понятия позволяют в универсальных наглядных образах объяснить особенности поведения конкретных систем.

Наряду с термином «С.» для обозначения данного направления широко употребляются также названия, как нелинейная неравновесная термодинамика, теория самоорганизации, теория *автоволов*, подбрасывающие выбор объекта или метода исследования.

Лит.: Эбеллинг В., Образование структур при необратимых процессах, пер. с нем., М., 1979; Хакем Г., Синергетика, пер. с англ., М., 1980; его же, Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах, пер. с англ., М., 1985; Романовский Ю. М., Степанова Н. В., Чернавский Д. С., Математическое обоснование, М., 1984; Пригожин И., Об существующем и подыскиваемом, пер. с англ., М., 1985.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ — кристаллы, выращенные в лаб. или заводских условиях. Имеют то же атомное строение, что и природные, часто совершеннее их. Из 3000 известных природных минералов искусственно выращено только неск. сотен, тогда как из 10⁴ синтезированных неорганич. и 10⁶ органич. кристаллов подавляющее большинство не имеет природных аналогов. Выращивание объёмных и тонкоплёночных кристаллов осуществляется из газовой фазы, из растворов и из расплавов (см. *Кристаллизация, Эпитаксия*). Хим. состав и размеры С. к. разнообразны: от неск. г до неск. кг. Для практич. применений существенное значение имеют лишь 20—30 С. к. (см. табл.). Они служат осн. функциональными элементами микроэлектроники, вычислит. техники, оптики и др.

Лит.: Современная кристаллография, под ред. В. К. Вайштейна, т. 3, М., 1980; Чернов А. А., Физика кристаллизации, М., 1983; Тимофеева В. А., Физико-химические и метастабильные основы раствор-расплавного построения полных технических кристаллов, М., 1990. В. А. Тимофеева.
СИНУС-ГОРДОНА. УРАВНЕНИЕ — релятивистски инвариантное ур-ние, в пространственно-временных переменных имеющее вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + m^2 \sin u = 0; \quad (A)$$

$$-\infty < x, t < \infty, u \in R^1, m > 0.$$

Название предложено в 1960-х гг. М. Крускалом (М. Kruskal) по аналогии с линейным *Клейна* — *Гордона уравнением* (где вместо $\sin u$ стоит u). В характеристических (светоподобных) переменных ($\sigma = x + t$, $\tau = x - t$) С.-Г. у. выглядит так:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \sigma \partial \tau} + m^2 \sin u = 0; \quad \sigma, \tau, u \in R^1, m > 0. \quad (B)$$

Как в случае (А), так и в случае (В) С.-Г. у. допускает представление Лакса

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [L, M]$$

с линейными операторами L и M ($[L, M] = LM - ML$), что позволяет применить к нему *обратной задачи рассеяния метод*.

Коши задача для С.-Г. у. формулируется след. образом.

Случай (А):

$$u|_{t=0} = u_1, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = u_2;$$

$$\frac{du_i}{dx}, u_2 \in S(R^1); \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} u_1(x) \equiv 0 \pmod{2\pi},$$

Случай (В):

$$u|_{t=0} = u_0; \quad \frac{du_0}{d\sigma} \in S(R^1);$$

$$\lim_{|\sigma| \rightarrow \infty} u_0(\sigma) \equiv 0 \pmod{2\pi}.$$

Здесь $S(R^1)$ — пространство Шварца быстроубывающих ф-ций. Задачи Коши (А) и (В) при нек-рых доп. ограничениях на нач. данные однозначно разрешены в указанных классах, и множества их решений совпадают. Эволюция данных рассеяния соответствует действию L -операторов и дается явными ф-лами, а решения $u(x,t)$ и $u(\sigma,\tau)$ находится с помощью инте-

Наиболее распространенные синтетические кристаллы

Название	Хим. ф-ла	Макс. вес, размер	Применение
Кварц	SiO ₂	от 1 до 15 кг	Пьезоэлементы, ювелирные изделия, оптич. приборы
Корунд	Al ₂ O ₃	стержни диам. 80—100 мм, дл. до 3 м, пластины 140×300×30 мм	Приборостроение, часовая пром-сть, ювелирные изделия, рубиновый лазер, плантовый усилитель, сапфировые подложки и «окна» в микроэлектронике
Рубин	Al ₂ O ₃ с примесью Cr		
Свифир	Al ₂ O ₃ с примесью Fe		
Германий	Ge	до 10 кг	Полупроводниковые приборы
Кремний	Si	до 30 кг	
Галлий	KCl, NaCl	от 1 до 100 кг	Синтиляторы
Сегнетова соль	KNaC ₄ H ₄ O ₆ ·4H ₂ O	от 1 до 25 кг	Пьезоэлементы
Триглицинсульфат	NH ₂ CH ₂ COONH ₂	от 1 до 40 кг	Пьезоэлектрич. элементы
Дигидрофосфат калия KDP	KH ₂ PO ₄	от 1 до 40 кг	Пьезоэлементы, нелинейные кристаллы, электроника
Алюминат иттрия	Y ₃ Al ₅ O ₁₂	500×500×300 мм	Лазеры, ювелирные изделия
Железистый гранат	Y ₃ Fe ₅ O ₁₂	40×40×150 мм	
Гадолиний-галмиевый гранат	Gd ₃ Ga ₅ O ₁₂	30×30×30 мм	Акустоэлектроника
Алмаз	C	20×80×200 мм	Подложки для магн. плёнок
Наобат лития	LiNbO ₃	от 0,1 до 3 мм	Абразивный материал
Нафталин	C ₁₀ H ₈	10×20×200 мм	Пьезоэлементы, акустоэлектрич. и электрооптич. элементы
Гидрогалит калия	CaH ₂ O ₄ ·K	блоки в веск. кг	Синтиляторы, детекторы частиц
Сульфид кадмия	CdS	до 1 кг	Рентг. анализаторы, нелинейная оптика
Кальцит	CaCO ₃	20×20×100 мм	Полупроводниковые приборы
Сульфид цинка	ZnS	10×30×30 мм	Оптич. приборы
Арсенид галлия	GaAs	20×20×100 мм	Полупроводниковые приборы
Фосфид галлия	GaP	—	—
Молибдат иттрия	Y ₂ (MoO ₄) ₃	100×100×100 мм	Лазеры
Двуокись циркония (с добавкой Y ₂ O ₃ до 10%)	ZrO ₂	100×100×100 мм	Ювелирные изделия, оптика
Двуокись гафния (с добавкой Y ₂ O ₃ до 10%)	HfO ₂	—	—
Вольфрамат калия	K ₂ WO ₄	10×20×200 мм	Лазеры
Алюминат иттрия	YAlO ₃	10×10×100 мм	—
Алюминий (трубы разл. сечений)	Al	дл. до 1 м, диам. 3×20 см	Металлургия

гральных ур-ний типа Гельфанда — Левитана — Марченко.

Гамильтонова формулировка С.-Г. у. заключается в том, что, напр., в случае (А) оно представляет собой *гамильтонову систему* с гамильтономом

$$P_0 = \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \frac{1}{2} \pi^2(x) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + m^2(1 - \cos u) \right\} dx$$

и симплектик. формой (см. *Симплектическая структура, Симплектическое многообразие*)

$$\Omega = \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx(x) \wedge du(x) dx, \quad \pi(x) = \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Эта система является вполне интегрируемой, и переход от переменных x и t к данным рассеяния соответствующего оператора L является канонич. преобразованием канонических переменных типа действие — угол. Фазовое пространство параметризуется канонически сопряженными переменными трех типов:

- 1) $0 \leq \rho(p) < \infty, 0 \leq \varphi(p) < 2\pi, p \in \mathbb{R}^1$;
- 2) $\rho_a, \varphi_a \in \mathbb{R}^1, a=1, \dots, N_1; N_1 \geq 0, N_1 \in \mathbb{Z}$;
- 3) $\eta_b, \xi_b \in \mathbb{R}^1, 0 \leq \alpha_b < 8\pi/\gamma, 0 \leq \beta_b < 2\pi; b=1, \dots, N_2, N_2 \geq 0, N_2 \in \mathbb{Z}$.

Полная энергия P_0 и полный импульс

$$P_1 = \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} \pi(x) \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

полю и в новых переменных выглядят след. образом:

$$P_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{p^2 + m^2} \rho(p) dp + \sum_{a=1}^{N_1} \sqrt{\frac{1}{\rho_a^2} + M^2} + \sum_{b=1}^{N_2} \sqrt{\eta_b^2 + (2M \sin \theta_b)^2};$$

$$P_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p \rho(p) dp + \sum_{a=1}^{N_1} p_a + \sum_{b=1}^{N_2} \eta_b, \quad M = \frac{\delta m}{\gamma}, \quad \theta_b = \frac{\gamma}{16} \alpha_b.$$

В случае (В) также получается вполне интегрируемая гамильтонова система.

Одно из приложений t к квантовой теории поля. Пусть $\psi(x, t)$ — скалярное поле с лагранжианом

$$L = \frac{1}{2\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right)^2 - \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 - 2m^2(1 - \cos \psi) \right\} dx$$

(здесь γ — константа связи). Такой лагранжиан появляется как часть квантового лагранжиана для мя. реалистич. моделей в КТП. С.-Г. у. является ур-нием Эйлера — Лагранжа для этого лагранжиана. При квазиклассич. квантовании поля и, роль играют приведенные выше выражения для P_0 и P_1 . Первые члены в правых частях указаний осн. ф-л отвечают частицам массой m — частицам осн. поля. Переменным второго и третьего типов соответствуют локализованные решения С.-Г. у. — солитоны (в КТП) и двойные солитоны массы M и $2M \sin \theta$. Система обладает законом сохранения (*топологический заряд*):

$$Q = \frac{1}{2\pi} (\psi(+\infty, t) - \psi(-\infty, t)), \quad Q \in \mathbb{Z}.$$

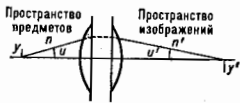
Частицы первого и третьего типов имеют заряд, равный 0, а у частиц второго типа заряд равен ± 1 . Части-

цы с одинаковыми зарядами отталкиваются, а с разными зарядами — притягиваются. Наличие бесконечного числа законов сохранения означает, что при рассеянии сохраняются кола-ва (частицы каждого типа; n -частичная матрица рассеяния (S-матрица) сводится к парным S-матрицам. С помощью интеграла по траекториям можно вычислить квантовые поправки к массам и к квазиклассической S-матрице солитонов. Одним из нетривиальных свойств указанной модели является возникновение левого спектра частиц (солитонов), в то время как лагранжиан теории содержит только одно поле. Кроме того, в приближении слабого взаимодействия (т. е. когда γ мало) солитоны — массивные частицы и сильно взаимодействуют.

Лит.: Гинзбург С. П., Избрание на главном основании и связанные с ним геометрические задачи, М.—Л., 1937; A. B. I. L. M. (и др.), Method for solving the sine-gordon equation, *Phys. Rev. Lett.*, 1973, т. 30, р. 1282; Тахтаджян И. Л. А., Фаддеев Л. Д., Существенно-неинтегрируемая одномерная модель классической теории поля, *АТМО*, 1974, т. 21, № 2, с. 160; и ж. е. Гамильтонова система, связанная с уравнением Уитни и Миллс, *Спр. Матем. ин-та АН СССР*, 1976, т. 14, с. 254; Корсаки В. Е., Фаддеев Л. Д., Квантование солитонов, *АТМО*, 1975, т. 25, № 2, с. 147; Кодел В. А., Котлярю В. П., Посты периодические решения уравнения Уитни — Миллс, *ДАН УССР, сер. АИ*, 1976, № 10, с. 676; Пелли и Фелдман Е. П., Некоторые точные методы в теории реллиевых волн, *Изв. вузов. Радиофизика*, 1976, т. 19, № 5—6, с. 883.

Л. А. Тахтаджян.

СИНУСОВОЕ УСЛОВИЕ — условие, соблюдение к-рого необходимо, чтобы оптич. система, исправленная в отношении *об сферической аберрации*, давала безаберрационное изображение y' малого осевого элемента y , расположенного перпендикулярно осн. С. у. выражается ф-лой $\sin u / \sin u' = \beta n / n'$, где u и u' — углы, образуемые оптич. осью и лучом, проходящим через точку предмета на осн в пространстве предметов и в пространстве изображений соответственно (рис.); n и n' — показатели преломления среды по обе стороны оптич.



системы; $\beta = y'/y$ — линейное увеличение оптич. системы.

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ — см. *Гармонические колебания*.

СИМФАЭНОСТЬ — совпадение по фазе двух или нескольких периодич. колебаний. Опираясь на более общее понятие когерентности, С. можно определить как частный случай когерентности, при к-ром разность фаз колебаний постоянна и равна нулю (на рис. 1 см.

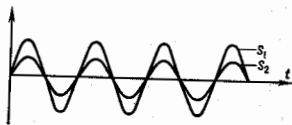


Рис. 1.

сифазные гармоники колебания, описываемые ф-циями вида $S_1(t) = A_1 \sin(\omega t + \varphi_0)$, где A_1 — амплитуда, $\omega = 2\pi/T$ — круговая (циклическая) частота, T — период колебаний, φ_0 — начальная фаза; эти колебания сифазны, если $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2\pi n$, где $n = 0, 1, 2, \dots$; на рис. 2 — сифазные колебания взаимно перпендикулярных векторов напряженностей электр. и магн. полей.

Примеры сифазных колебаний: 1) колебания всех точек стоячей волны; они происходят с разл. отклоне-

ниями от нулевого положения, но в одинаковой фазе (во время как в безупречной, наоборот, колебания всех точек происходят с одинаковыми отклонениями, но в разл. фазах); 2) а нелинейных оптич. средах колебания вынуждающей волны нелинейной поляризации

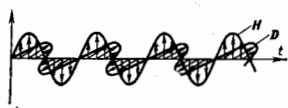


Рис. 2.

и, напр., возбуждаемой ее волны поля второй гармонической при наличии т. е. фазового (волнового) синхронизма. При отсутствии синхронизма, т. е. при наличии волновой расстройки, С. волн поляризации и поля исчезает, в результате чего возникают пространственные бивны.

Лит.: Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э., Теория колебаний, 13 изд., М., 1981; Основы теории колебаний, 2 изд., М., 1988. Т. И. Соколов.

СИНХРОБЕТАТРОННЫЙ РЕЗОНАНС — резонансное возбуждение колебаний частиц в циклич. ускорителях на комбинац. частотах, составленных из частот бетатронных и синхротронных колебаний. Возникает при выполнении условия

$$m_x \omega_x + m_z \omega_z + m_c \omega_c = n \omega_0,$$

где $\omega_{x,z}$ — частоты радиальных и аксиальных (вертикальных) бетатронных колебаний (по осям x и z), ω_c — частота синхротронных колебаний, ω_0 — частота обращения частиц в ускорителе, m_x, m_z, m_c — целые числа.

К возникновению С. р. приводит несколько причин: зависимость частот бетатронных колебаний от импульса частиц (т. е. хроматизм ускорителя), зависимость притока энергии, получаемой частицами при прохождении ускоряющих промежутков, от радиальной координаты, отклонение плоскости бетатронных колебаний от нормальной к равновесной орбите, а также локализация возмущений. Для компенсации первого эффекта в магн. структуру ускорителей вводят секстипольные линзы, для компенсации второго стараются располагать ускоряющие станции на участках с небольшой (лучше всего с нулевой) дисперсионной ф-цией (описывающей зависимость радиального положения частицы от её импульса).

С. р. налагает серьезные ограничения на изготовление накопительных колец ускорителей. Обычно частоты колебаний должны быть удалены от С. р. С. р. может заметно ограничить светимость ускорителей со встречными пучками (коллайдерами).

Лит. см. при ст. Синхротрон электронами.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ — согласование частот, фаз или др. характеристик сигналов, генерируемых взаимодействующими колебательными системами. Различают в зависимости от С. к., когда парциальные подсистемы перестраивают режим колебаний друг друга, и в естественную (вынужденную) С. к., когда характеристики колебаний системы (систем) изменяются под действием внеш. силы. Вынужденную синхронизацию по частоте колебаний, т. е. навязывание системы, характеризующейся в автономном режиме одной частотой колебаний, др. частоты, определенной внеш. силой, называют *захватыванием частоты*. Захватывание частоты — простейший пример явления синхронизации, к-рый был описан еще Х. Гюйгенсом (Ch. Huygens) в связи с ускорением или замедлением хода часов, висящих на независимом колеблющемся балке (см., напр., [1]).

Наиб. полно развита теория С. к. для квазигармонических колебаний в слабо нелинейных системах [2—4].

В частности, усредненные по периоду внеш. силы уравнения для комплексной амплитуды a нелинейного генератора с одной степенью свободы, находящегося под действием слабой гармонической силы, имеют вид:

$$\dot{a} = \mu[a(1 - |a|^2) + \beta|a|^2 a + a_{внеш} + \xi a], \quad (1)$$

где μ, β, ξ — действительные параметры: ξ — расстройка между частотой автоколебаний и частотой внеш. силы, μ — коэф. усиления в автономном генераторе, β — нелинейный сдвиг частоты. Режиму С. к. соответствует устойчивое положение равновесия системы (1). В исходном же (3-мерном) фазовом пространстве режиму С. к. отвечает устойчивый *предельный цикл*. При увеличении ξ режим С. к. либо перестает существовать (при слабых внеш. сигналах), либо теряет устойчивость (в случае сильных сигналов). Область значений расстроек, для к-рых реализуется режим С. к., наз. *полосой захватывания*. Границы полосы захватывания находятся из (1); из условия существования режима С. к. ($\dot{a} = 0$) устанавливается резонансная кривая

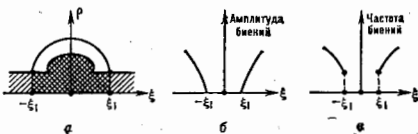


Рис. 1.

$\rho = \rho(\xi)$, где $\rho = |a_0(\xi)|^2$ — интенсивность автоколебаний в режиме С. к., и по линеаризованному уравнению определяется устойчивость этого режима. На рис. 1 показаны полосы захватывания в случаях слабых и сильных сигналов. На рис. 2 изображены последовательности фазовых портретов на плоскости (Re a, Im a), отвечающих (1) при разных значениях расстройки. При

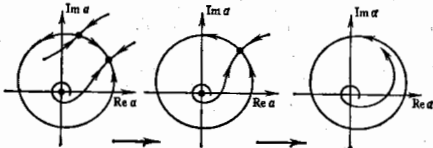


Рис. 2.

переходе через границу области захватывания режим С. к. сменяется режимом *бивней* — наблюдается *бифуркация Андронова — Хопфа* (при сильных сигналах) или *бифуркация рождения предельного цикла из петли сепаратрисы седло — узел* (при слабых сигналах). В исходном (3-мерном) фазовом пространстве переходу к режиму бивней отвечает рождение притягивающего двумерного тора с квазипериодич. обмоткой. Аналогичным образом можно исследовать С. к. ансамбля генераторов, находящихся под действием одной и той же внеш. гармонической силы [5, 6].

Явление взаимной синхронизации генераторов квазигармонических колебаний в простейшем случае бигармонического резонанса ($\omega_2 = 2\omega_1 + \xi$) может быть исследовано в рамках системы уравнений для комплексных амплитуд a_1, a_2 , взаимодействующих мод в автогенераторе с двумя степенями свободы:

$$\dot{a}_1 = \lambda_1 [1 - (|a_1|^2 + \rho_{12}|a_2|^2) - \sigma_1 a_1^2] \exp i \xi t, \quad (2)$$

$$\dot{a}_2 = \lambda_2 [1 - (|a_2|^2 + \rho_{21}|a_1|^2) - \sigma_2 a_2^2] \exp i \xi t,$$

где ξ — расстройка от точного резонанса, $k_{1,2}$ — инкременты каждой из мод, ρ_{12} , ρ_{21} — параметры, характеризующие конкуренцию мод, а $\sigma_{1,2}$ — их резонансное взаимодействие. Здесь также режиму С. к. отвечает устойчивое состояние равновесия, граница области устойчивости к-рого и определяет границу области взаимной синхронизации [3]. Взаимная синхронизация наблюдается в системах с числом степеней свободы ≥ 2 , и во многих ситуациях после разрушения режима С. к. возможно возникновение стохастических автоколебаний (см. *Стохастические колебания*). Явление С. к. наблюдается не только в случае, когда частоты парциальных генераторов близки друг к другу, но и когда они близки к кратным друг друга (синхронизация на гармониках и субгармониках). Именно за счёт взаимной синхронизации мод оптич. резонатора удаётся реализовать режим генерации ультракоротких импульсов в лазерах [7].

В сильно нелинейном случае усреднённое описание, приводящее к уравнениям типа (1) и (2), не адекватно задаче, и здесь используется качество теории динамических систем. В этой теории явление синхронизации периодич. колебаний двух автоколебл. систем можно описать следующим образом. Каждой из систем

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^m, \quad (3)$$

$$\dot{y} = g(y), \quad y \in \mathbb{R}^m \quad (4)$$

свойственны периоды, автоколебания, т. е. в её фазовом пространстве имеется устойчивый предельный цикл — L_1 и L_2 соответственно. Система

$$\dot{x} = f(x) + \gamma h(x, y), \quad (5)$$

$$\dot{y} = g(y) + \gamma r(x, y)$$

при $\gamma = 0$ будет иметь притягивающий двумерный тор $T_0 = L_1 \times L_2$ (каждая система колеблется независимо от другой). При возрастании параметра связи γ движение в парциальных подсистемах системы (5) переставит быть независимым, что отвечает бифуркациям на торе T_0 (остающемся аттрактором для системы (5)). В частности, явлению синхронизации отвечает рождение устойчивого предельного цикла на этом торе.

Более подробную информацию о перестройках в системе при изменении параметра связи даёт т. н. дьявольская лестница — график зависимости числа вращения системы на торе T_0 от параметра связи. [Число вращения — это предел отношения фаз бывших независимыми при $\gamma = 0$ колебаний парциальных генераторов: $\mu = \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t)/\psi(t)$].

Зависимость числа вращения от величины параметра связи имеет вид непрерывно

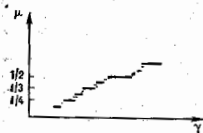


Рис. 3.

уменьшающихся ступеней (рис. 3). Точнее, ф-ция $\mu(\gamma)$ растёт на канторовом множестве. Каждое своё значение, равное отношению целых чисел p/q (синхронизация), число вращения принимает, вообще говоря, на некотором интервале, а числа p и q соответствуют номерам гармоник, на к-рых осуществляется взаимная синхронизация. Если следить за изменением не только параметра связи, но и др. параметра (напр., надкритичности в каждом из генераторов), то области синхронизации будут изображаться уже не на прямой, а на плоскости. Обычно эти области имеют вид язычков [8] (т. н. языки Арнольда [9]) — рис. 4.

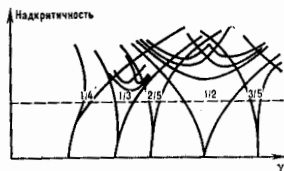


Рис. 4.

Взаимное согласование движений свойственно генераторам не только периодических, но в стохастических автоколебаний. Принципиальное отличие от случая периодич. колебаний здесь в том, что движения взаимодействующих неидентичных подсистем согласуются лишь в среднем во времени. При этом могут быть одинаковыми топология проекций *странных аттракторов* на парциальные подпространства, их размерности, спектры мощности парциальных колебаний. В то же время сами реализации локально по времени могут не совпадать. На рис. 5 представлены странные аттракторы парциальных подсистем в автономном режиме

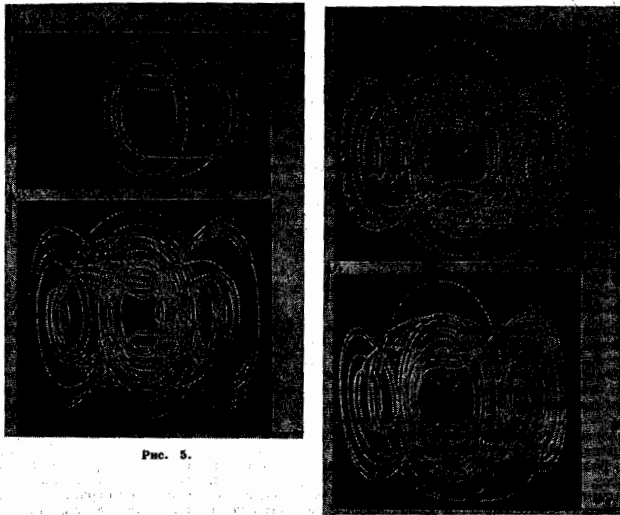


Рис. 5.

($C=0$) и проекция аттрактора на парциальные подпространства в режиме стохастич. синхронизации ($C=10$) для системы, описываемой ур-ниями вида:

$$\begin{aligned} \ddot{x}_1 + k_1 \dot{x}_1 + (1+q \cos \Omega t)x_1 + z &= C(x_2 - x_1), \\ \ddot{x}_2 + k_2 \dot{x}_2 + (1+q \cos \Omega t)x_2 + z &= C(x_1 - x_2) \end{aligned} \quad (6)$$

(напр., $Q=2$, $k_1=0,48$, $k_2=0,45$ для двух связанных параметрически возбуждаемых генераторов [10]).

Степень стохастич. синхронизации может быть различной; в частности, в нек-рых ситуациях, когда взаимодействуют идентичные подсистемы, совпадение парциальных колебаний может быть полным.

Лит.: 1) Влекман И. И. Синхронизация в природе и технике, М., 1981; 2) Андронов А. А., Витт А. А., Кратчайшая теория захватывания, в кн.: Андронов А. А., Собр. трудов, М., 1956; 3) Бланкворт О. Анализ нелинейных систем, пер. с англ., М., 1969; 4) Рабинович М. И., Трубецков Д. И., Введение в теорию колебаний и волн, М., 1984; 5) Aizawa X., Synergetic approach to the phenomena of mode-locking in nonlinear systems, *Prog. Theor. Phys.*, 1978, т. 56, № 3, p. 703; 6) Рабинович М. И., Стохастич. автоколебания и турбулентность, «УФН», 1978, т. 125, с. 123; 7) Квантовая радиофизика, 2 изд., т. 2 — Хван и Я. И., Динамика квантовых генераторов, М., 1975; 8) Ариэль В. И., Малые знаменатели. 1. Об отбракованных окружностях на себя, Изд. АН СССР, Сер. мат., 1981, т. 25, с. 21; 9) Thompson J. M., Stewart H. B., Nonlinear dynamics and chaos, N. Y., J. Wiley, 1986; 10) Афраймович В. С., Вержич Н. Н., Рабинович М. И., Стохастич. синхронизация колебаний в диссипативных системах, «Изв. вузов. Радиофизика», 1986, т. 29, № 8, с. 1050.

В. С. Афраймович, М. И. Рабинович.

СИНХРОНИЗМ (от греч. *synchronizō* — одновременно) — условие эфф. обмена энергией при взаимодействии волн, заключающееся в сохранении определенных фазовых соотношений между волнами на протяжении всей области взаимодействия.

В условиях С. интенсивности взаимодействующих волн меняются в первом приближении пропорционально квадрату длин области взаимодействия z^2 (рис.).

При нарушении С. интенсивности волн осциллируют вдоль оси z с пространственным периодом $2l_{\text{пер}}$, достигая макс. изменения на длине $l_{\text{пер}}$, называемой длиной когерентного взаимодействия. Макс. изменение интенсивностей волн пропорционально $l_{\text{пер}}$ и при сильном нарушении С. очень мало.

Термин «С.» получили широкое распространение при описании взаимодействия эл.-магн. волн. Для плоских эл.-магн. волн частоты ω , распространяющихся в нелинейной среде вдоль оси z , в приближении медленно меняющихся амплитуд интенсивности волн (см. *Нелинейная оптика*)

$$I \propto |A|^2 \cos^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{k_p - k}{2} z \right), \quad (1)$$

где k , k_p — волновые векторы собственной эл.-магн. волны и волны нелинейной поляризации, $\text{sinc}(z) = \sin z/z$. При этом $2l_{\text{пер}} = 2\pi/|k_p - k|$. Поскольку $k = \omega/v_D$ и $k_p = \omega/v_{Dp}$, где v_D , v_{Dp} — фазовые скорости эл.-магн. волны и волны нелинейной поляризации соответственно, то условие С. можно записать как $v_D = v_{Dp}$. Т. о., условие С. заключается в равенстве фазовых скоростей собственной эл.-магн. волны и волны нелинейной поляризации среды на частоте ω .

Волна нелинейной поляризации на частоте ω возникает, напр., при распространении в среде эл.-магн. волн с частотами ω_1 и ω_2 , причём $\omega_1 + \omega_2 = \omega$, и волновыми векторами k_1 и k_2 . Условие С. в этом случае

принимает вид $k_1 + k_2 = k$ или, в общем случае, $k_1 + k_2 = k$. Этот процесс наз. генерацией суммарной частоты, частным случаем k -рога является генерация второй гармоник (при $\omega_1 = \omega_2$). Условие С. можно трактовать как сохранение суммарного импульса взаимодействующих волн: $hk_1 + hk_2 = hk$. При нарушении условия С. импульс волн частично передается среде, а k -рой они распространяются.

В СВЧ-приборах, напр. *лампе бегущей волны* (ЛБВ), вместо волны поляризации следует рассматривать волну конвекционных токов, фазовая скорость k -рой совпадает со скоростью потока электронов. В этом случае условие С. заключается в совпадении фазовой скорости эл.-магн. волны со скоростью электронного потока. Это рассмотрение соответствует приближению, не учитывающему обратного влияния эл.-магн. волны на поток электронов (в нелинейной оптике подобный подход наз. приближением заданного поля). При учёте этого влияния наиб. усиление эл.-магн. волн в ЛБВ достигается при нек-ром превышении начальной скорости взаимодействия над фазовой скоростью эл.-магн. волны.

При акустич. взаимодействии (см. *Акустическая Дифракция света на ультразвуке*) условие С. $k \pm K = k'$, где k , k' и K — волновые векторы падающей, дифрагированной (рассеянной) и акустич. волн соответственно, называют *Брэгга — Вульфа условиями*.

Для выполнения условия С. в общем случае приходится принимать спец. меры, напр. использовать замедляющие системы в СВЧ-приборах, или двулучепреломляющие кристаллы в нелинейной оптике, подбирая частоту акустич. волны в акустоопт. устройствах.

Спектральная ширина S определяется как ширина частотного интервала $\Delta\omega_c$, в пределах k -рого фазовое рассогласование взаимодействующих волн в области взаимодействия не превышает

$$\Delta\omega_c \approx \frac{2\pi}{10k_p/v_D - dk/d\omega l}$$

где l — длина области взаимодействия. Поскольку $dk/d\omega \approx v_{гр}^{-1}$, где $v_{гр}$ — групповая скорость, то спектральная ширина S велика в случае равенства групповых скоростей взаимодействующих волн. Это условие т. н. *группового синхронизма* (в отличие от группового С., условие $k_p = k$ называют *фазовым* или *одноименным С.*). При выполнении условия группового С., ограниченные в пространстве волновые пакеты распространяются с одинаковой групповой скоростью и их эффективное взаимодействие происходит на большой длине даже при малой длине волновых пакетов (т. е. при широком спектре). Так, в ЛБВ с однородной замедляющей системой дисперсия эл.-магн. волн очень мала и групповые скорости взаимодействующих волн практически совпадают, что обуславливает широкую полосу усиления ЛБВ (октана и выше). В *лампе обратной волны* (ЛОВ), напротив, групповая скорость эл.-магн. волны и скорость потока электронов противоположны, поэтому усилители на ЛОВ не могут быть широкополосными и ЛОВ часто используют как узкополосный перестраиваемый регенеративный усилитель.

В нелинейной оптике из-за сильной дисперсии групповой скорости S наблюдается только в отд. случаях. В акустике, напротив, из-за малой дисперсии условия фазового и группового С. выполняются одновременно для большого числа спектральных компонент, что приводит к накоплению нелинейных эффектов на больших длинах и образованию *ударных волн*.

При взаимодействии волновых пучков, ограниченных в поперечном сечении, условие группового С. принимает более общий вид, а именно — как равенство векторов групповых скоростей взаимодействующих волн. При отличии направления векторов групповых скоростей ограниченные в пространстве волновые пучки испытывают боковой снос относительно друг друга,

что приводит к уменьшению области эфф. взаимодействия. Это явление обычно характеризуется угл. шириной C . — расхождение взаимодействия, в пределах k -рой фазовой рассогласование не превышает L . В нелинейной оптике боковой свос взаимодействующих пучков наз. а п е р у р и ш м а э ф ф е к т м и обусловлен отличием направления векторов фазовой и групповой скоростей для необиоживенных волн в анизотропных кристаллах (см. *Оптическая анизотропия*). Апертурный эффект полностью отсутствует при т. п. 90-градусном C ., когда все взаимодействующие пучки распространяются перпендикулярно оптич. оси. При 90-градусном C угл. ширина C резко возрастает и ограничена дифракц. распыливанием пучков, так же как спектральная ширина C при групповом C ограничена дисперсионным распыливанием волновых пакетов.

Лит.: Цернике Ф., Милвинтер Дж., Прикладная нелинейная оптика, пер. с англ., М., 1976; Виноградова М. В., Руденко О. В., Сухоруков А. П., Теория волн, 2 изд., М., 1990; Ахманов С. А., Дьячков Ю. Е., Чиркин А. С., Введение в статистическую радиофизику и оптику, М., 1981; Дмитриев В. Г., Тарасов Л. В., Прикладная нелинейная оптика, М., 1982. С. М. Нотыко.

СИНХРОННАЯ СИСТЕМА отсчёта — система отсчёта, в k -рой компоненты метрического тензора $g_{00} = c^2$, $g_{0i} = 0$ (индекс 0 соответствует временной координате $x^0 = t$, индекс i — 1, 2, 3 — пространственным координатам x^i). В C с. возможна однозначная синхронизация часов в различных точках пространства (отсюда название) по методу Эйнштейна (т. е. с помощью послышки светового сигнала из точки B в бесконечно близкую точку A и обратно и т. д. вдоль нек-рой линии в пространстве, причём одновременным с моментом приёма сигнала в точке A считается момент времени в точке B , равный полусумме моментов отправления и обратного прибытия сигнала в эту точку, см. *Относительности теория*), т. к. результат не зависит от линии, вдоль k -рой проводится синхронизация. В частности, в C с. возможна синхронизация вдоль любой замкнутой линии, что, вообще говоря, не имеет места в др. системах отсчёта. Координата t представляет собой *собственное время* наблюдателя, покоящегося в каждой точке пространства. C с. можно ввести в нек-рой окрестности любой регулярной точки пространства-времени. Физ. реализация C с. даётя системой пробных частиц, двигающихся (безвихревым образом) по геодезическим линиям в заданном пространстве-времени (т. е. по т. н. конгруэнции геодезических l): их траектории выбирают в качестве линий $l^2(t) = \text{const}$ в C с. Для этих частиц C с. являются также и *сопутствующей системой отсчёта*. Характерное свойство C с. — неstationарность, транзитивность, поле в ней не может быть постоянным (за исключением тривиального случая плоского пространства-времени). C с., как правило, не покрывает всего пространства-времени ввиду пересечения геодезических на кausтиках, что приводит к обращению в нуль метрической метрики тензора на регулярных трёхмерных гиперповерхностях. Для нахождения метрики пространства-времени за этими гиперповерхностями необходимо перейти к другой системе отсчёта.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988.

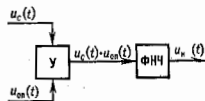
СИНХРОНИЗНЫЙ ДЕТЕКТОР — устройство для извлечения информации из ВЧ-сигнала $u_c(t) = A(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$, модулированного по амплитуде или фазе, путём нелинейного преобразования — умножения на синхронный опорный сигнал $u_{0n}(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ с последующей НЧ-фильтрацией (рис. 4). Низкочастотная составляющая в спектре сигнала-произведения $u_c(t)u_{0n}(t)$ имеет вид:

$$u_{нч}(t) = \frac{A(t)A_0}{2} \cos[\varphi(t) - \varphi_0]$$

и при $\varphi(t) = \text{const}$ пропорциональна искомой амплитуде $A(t)$, а при $\varphi(t) = \text{const}$ и $\varphi_0 = \pi/2$, $\varphi(t) \ll \pi/2$

пропорциональна фазе $\varphi(t)$. Осн. особенность C д. — его помехозащищённость и способность выделять полезный сигнал на фоне шумов — определяется тем, что всякий входной сигнал C д., частота k -рого ω , образует низкочастотную составляющую с частотой

Рис. 4. Блок-схема синхронного детектора: У — умножающее устройство, ФНЧ — фильтр низких частот.



$\delta\omega = \omega - \omega_0$. Если $\delta\omega > \Delta\omega$, где $\Delta\omega$ — полоса пропускания фильтра низких частот, то паразитный сигнал подавляется при фильтрации. Умножение сигналов в C д. осуществляется обычно электрич. цепью с изменяемыми параметрами (напр., активным сопротивлением, см. рис. 2) или электронным усилителем (см. *Усилители электрических колебаний*), коэф. передачи k -рого изменяется под действием опорного сигнала. В общем

Рис. 2. Умножение сигналов на изменённом сопротивлении.



случае опорным сигналом C д. может служить периодич. сигнал произвольной формы. Широко используется прямоугольный опорный сигнал, для k -рого операции умножения осуществляются путём скачкообразного изменения (переключения) параметра C д. (сопротивления, ёмкости или др.). Для этого обычно применяются быстродействующие диодные или транзисторные переключатели. Для получения требуемого фазового соотношения между опорным и детектируемым сигналами в цепь опорного сигнала включается фазовращающее устройство (см. *Фазовращатели*).

Лит.: Скрипкив Ю. А., Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей, М., 1975; Тятин С. У., Шен И. К., Полупроводниковая схемотехника, пер. с нем., М., 1982. А. В. Степанов.

СИНХРОТРОН — в широком (обычном в наст. время) смысле слова — кольцевой резонансный ускоритель заряж. частиц, как лёгких (электронов, позитронов), так и тяжёлых (протонов, антипротонов или ионов, см. *Синхротрон протонный*), с изменяющимся в процессе ускорит. цикла магн. полем и неизменным радиусом равновесной орбиты. Частота ускоряющего поля в C . меняется с изменением магн. индукции и таким образом приводится в соответствие с изменяющейся частотой обращения частиц.

C в узком (первоначальном) смысле слова — *синхротрон электронный* — кольцевой резонансный ускоритель ультрарелятивистских частиц — электронов и позитронов. Частота ускоряющего поля в таких C . не меняется в течение ускоряющего цикла, т. к. не меняется (или почти не меняется) скорость ускоряемых частиц.

СИНХРОТРОН ПРОТОННЫЙ — циклич. резонансный ускоритель протонов с изменяющимся во времени магн. полем и синхронно изменяющейся частотой электр. ускоряющего поля ω . Протонными синхротронами часто называют и аналогичные по устройству ускорители др. тяжёлых частиц: антипротонов, атомарных и молекулярных ионов и т. д.

Схема C п. приведена на рис. 1. Протоны, ускоренные в предварт. ускорителе — инжекторе 1, вводятся в кольцевую вакуумную камеру 2 с помощью спец. ал.-магн. инжекторной системы 3, k -рая обычно оканчивается пластинами с отклоняющим электростатич. полем (это поле по окончании инжекции выключается). Частицы ускоряются переменным высокочастотным

электрич. полем ускоряющих станций 4, размещённых в промежутке между электромагнитами 5, к-рые поворачивают и фокусируют частицы в поперечных направлениях (бетатронные колебания). Эти магниты расположены по кольцу в определённом порядке. Система

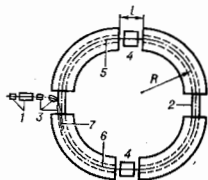


Рис. 1. Схема протонного синхротрона: 1 — инжектор; 2 — вакуумная камера; 3 — устройство ввода; 4 — ускоряющие электроды; 5 — электромагниты; 6 — равновесная орбита; 7 — пучок частиц.

электромагнитов 5 обеспечивает также устойчивость продольных синхротронных колебаний (радиально-фазовых). Траектории частиц в С. п. с точностью до неск. см совпадают с идеальной равновесной орбитой 6.

Индукция поля в электромагнитах В. импульс ускоряемых частиц p и радиус кривизны их траектории R связаны между собой соотношением $pc = eBR$, к-рое в удобных для практич. применения единицах имеет вид:

$$p[\text{МэВ}] = 300B[\text{Тл}] \cdot R[\text{м}]. \quad (1)$$

Это соотношение определяет геом. размеры С. п., к-рые в совр. ускорителях измеряются километрами. Частота ускоряющего поля $\omega_{\text{вч}}$ должна быть кратна частоте обращения частиц в ускорителе

$$\omega = qv/L, \quad (2)$$

где v — скорость частиц, L — длина их траектории, к-рая практически всегда может быть заменена длиной равновесной орбиты, т. е. величиной такой замкнутой кривой, к-рая принадлежит к числу возможных траекторий движения частиц с данным импульсом. Целое число q наз. кратностью q к числу ускоряющих электродов. Ф-ла (1) показывает, что индукция магн. поля в С. п. должна увеличиваться вместе с импульсом частиц. Для сокращения размеров и экономии электроэнергии в ускорителях на большие энергии всё шире начинает применяться сверхпроводимость. Частота ускоряющего поля должна увеличиваться вместе со скоростью частиц и в течение ускоряющего цикла может изменяться в неск. раз (она постоянна только при ускорении релятивистских частиц).

На рис. 2 изображена типичная зависимость B к ω от времени. Эта зависимость обычно носит периодич.

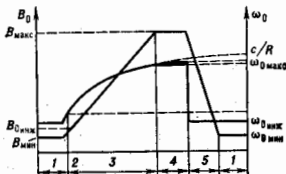


Рис. 2. Рабочий цикл протонного синхротрона: 1 — пауза; 2 — инжекция; 3 — ускорение; 4 — медленный вывод; 5 — быстрый вывод.

характер (в совр. С. п. возможны и более сложные режимы) и называется рабочим циклом (или циклом ускорения). После паузы 1 магн. поле начинает возрастать и при подходящем его значении происходит

инжекция 2, в течение к-рой вакуумная камера С. п. заполняется частицами, поступающими от предратр. ускорителя. В С. п. на умеренную энергию ($\approx 1 \text{ ГэВ}$) в качестве инжекторов обычно используются резонансные линейные ускорители; в С. п. на высокую и сверхвысокую энергию широко применяют каскадные схемы, в к-рых инжектором основного С. п. является небольшой С. п. — б у с т е р. Под действием ускоряющего ВЧ-поля инжектируемые частицы группируются в q сгустков; при этом теряется часть пучка, оказавшаяся вне сепаратрис, ограничивающих области устойчивости продольных колебаний. Захваченные в режим ускорения частицы ускоряются ВЧ электрич. полем, частота к-рого в соответствии с ф-лами (1) и (2) синхронизируется с магн. полем системами автоподстройки по пучку. Во время захвата и ускорения 3 частицы могут быть потеряны под действием ряда факторов: рассеяния на остаточном газе, влияния возмущений магн. и ускоряющего полей, коллективных эффектов, вызванных собою, полем пучка, его взаимодействием со стенками вакуумной камеры и т. д. После окончания стадии ускорения частицы выводятся (4) из С. п. и направляются польователями; для физ. экспериментов, инжекции в др. ускоритель и т. д. В связи с тем что детекторы имеют ограниченную скорость счёта, да совр. С. п. широко применяются схемы медленного вывода, растягивающие процессы вывода частиц до неск. секунд или более. Индукция магн. поля в течение медленного вывода не меняется (выходит «на площадку»).

Совр. С. п. представляет собой сложное инженерное сооружение, включающее целый ряд техн. систем: магн. систему, систему ускорения, вакуумную систему, системы инжекции и вывода, систему диагностики пучка, систему контроля и управления и т. д. Рассмотрим кратко две осн. системы: магнитную и систему ускорения.

Магнитная система обеспечивает поворот и фокусировку частиц. Жёсткость фокусировки определяется бетатронными частотами Q_r и Q_z — числом поперечных (радиальных и аксиальных) колебаний на оборот (см. *Бетатрон*). В соответствии с историч. традицией различают С. п. со слабой фокусировкой (в старой отечеств. литературе — синхротроны), у к-рых Q_r и $Q_z < 1$, и С. п. с сильной фокусировкой ($Q > 1$) (см. *Фокусировка частиц в ускорителе*). Для создания сильной фокусировки применяют магниты, у к-рых градиент магн. поля многократно меняет знак (см. *Знакопеременная фокусировка*). В качестве элементов магн. системы используются либо магниты с совмещёнными ф-циями, в к-рых создаётся магн. поле, имеющее как поворачивающую B_z , так и фокусирующую $\partial B_z/\partial r$ составляющие, либо магниты с разделёнными ф-циями, т. е. дипольные поворачивающие магниты без градиента ($\partial B_z/\partial r = 0$), и квадрупольные фокусирующие линзы, не имеющие поворотного магн. поля ($B_z = 0$).

Магниты в ускорителе объединяют в периоды, группы сложной конфигурации (периоды и супериоды магн. системы); иногда в С. п. на сверхвысокую энергию применяются и непрерывч. группы («вставки»), в к-рых размещаются спец. системы для исследования встречных пучков, мощные ускоряющие системы, системы аварийного вывода пучка и т. д. Магн. система включает также элементы (в виде отд. магнитов, дополнит. обмоток, шимов и т. д.) для коррекции возмущений магн. поля на орбите, вызванных систематич. или случайными отклонениями в поле магнитов, отклонками их устойчивости и т. д. Погрешности магн. систем становятся особенно заметными, если числа бетатронных колебаний Q_r и Q_z приближаются к целым (резонансное влияние погрешностей в индукции магн. поля) в получаемым значениям (погрешности в величине $\partial B_z/\partial r$).

Ускоряющая система обеспечивает ускорение частиц, а также устойчивость синхротронных (радиально-фазовых) колебаний импульса и продольной координаты

частицы около равновесного значения, соответствующего центру ускоряемого пучка. Ускоряющая система состоит из нескольких или многих ускоряющих стаций, возбуждающих нагруженные или полые (в ультрарелятивистских С. п.) резонаторы. Резонаторы располагаются в промежуточных между элементами магн. системы. Для управления частотой резонаторов широко применяется подмагничивание ферритов, к-рым нагружается резонатор. Частота резонатора синхронизируется с частотой обращения частиц с помощью спец. систем автоподстройки. Погрешности и шумы в частоте, напряжениях и др. параметрах ускоряющей системы приводит к шумовой раскочке амплитуды синхротронных колебаний. Стабилизирующим фактором является затухание фазовых колебаний, происходящее при увеличении полной (в релятивистском смысле) энергии частиц ($\sim \epsilon^{-1/2}$).

Основные характеристики протонного синхротрона. Наиб. важные характеристики ускорителей — предельная энергия и интенсивность ускоренного пучка. Совр. С. п. позволяют достичь самых высоких (в принципе неограниченных) значений энергии; интенсивность же С. п. слишком мала для их техн. применения. Поэтому осн. приложение С. п. — физика частиц высоких энергий. Как видно из (1), для повышения энергии необходимо увеличивать магн. жесткость ($B(z)R(z)$). Обычные железные магниты не позволяют достичь величин индукций, существенно превосходящих 2 Тл; поэтому в С. п. на сверхвысокие энергии используются сверхпроводящие магниты, индукция к-рых может достигать 6—8 Тл. Радиус С. п. также возрастает: предполагается, что в проектируемой в США установке SSC ср. радиус $\langle R \rangle$ будет равен 13,8 км. В связи с увеличением размеров установок становится С. п. также растёт, однако не очень быстро, т. к. размеры вакуумной камеры (и, следовательно, апертура магнитов) при этом, как правило, несколько сокращаются. Уменьшить размеры вакуумной камеры можно, сокращая размеры инжектируемого пучка (при инжекции из бустера этому способствует уменьшение размеров пучка, происходящее при его ускорении $\sim p^{-1/2}$). Среди др. применяемых мер укажем на совершенствование методов коррекции возмущений магн. поля, улучшение вакуума и связанное с этим уменьшение рассеяния на остаточном газе.

Ср. интенсивность С. п. (число ускоренных протонов в с) определяется ф-лой:

$$I = N/T,$$

где N — число частиц, ускоренных за рабочий цикл, T — длительность этого цикла.

Величина N определяется числом инжектиров. частиц и потерями во время ускорения. В совр. С. п. N ,

как правило, приближается к предельному значению, определяемому коллективными эффектами: допустимым сдвигом частоты поперечных колебаний, коллективными неустойчивостями и т. д. Длительность цикла ускорения зависит гл. обр. от скорости роста магн. поля в поворотных магнитах и меняется в очень широких пределах: от 0,05 с у быстрых бустеров до 100—150 с у С. п. на сверхвысокие энергии.

Осн. параметры нек-рых из действующих С. п. сведены в табл. Последний из этих С. п. — тэватрон — объединяет в себе функции ускорителя и ионационного кольца со встречными p — р пучками. Тэватрон — первый из С. п. со сверхпроводящими магнитами на энергию, измеряемую многими сотнями ГэВ. Наиб. крупные проектируемые установки: LHC — большой адронный столкновитель (СЕРН, Женева, 2 × 8 ТэВ) и SSC — сверхпроводящий суперстолкновитель (США, Техас, 2 × 20 ТэВ). Эти установки также объединяют в себе ф-ции С. п. и столкновителя. Намеченное время сооружения — 1996 и 1998 гг. соответственно.

Лит.: Коломенский А. А., Лебедев А. Н., Теория циклических ускорителей, М., 1962; Лебедев А. Н., Шаталов А. В., Основы физики и техники ускорителей, т. 1—3, М., 1981—83; Catalogue of high energy accelerators, Tsukuba, 1989. И. Р. Зенкевич,

СИХРОТРОН ЭЛЕКТРОННЫЙ — кольцевой резонансный ускоритель электронов (позитронов) на энергии от неск. МэВ до десятков ГэВ, в к-ром частота ускоряющего электрич. поля не меняется, ведущее магн. поле увеличивается во времени и равновесная орбита не меняется в процессе ускорит. цикла. Обычно электроны уже при инжекции являются ультрарелятивистскими; если же ускорение начинается с энергии ≤ 5 —7 МэВ, то в начале ускорит. цикла применяется бетатронный режим ускорения (см. *Бетатрон*).

Траектории ускоряемых в синхротроне электронов (позитронов) заполняют кольцевую область в вакуумной камере ускорителя. Обращаясь в ней, частицы многократно возвращаются к одним и тем же ускоряющим промежуткам, на к-рые подано переменное напряжение с частотой, в целое число раз q ($q \geq 1$) превосходящей частоту обращения частиц по т. и. равновесной орбите. Число q наз. кратностью ускорения. При каждом прохождении через промежуток фаза идеальной (равновесной) частицы остаётся неизменной, но фаза реальных частиц немного изменяется, колеблется около равновесного (синхротронного) значения. При ускорении пучок частиц развивается на ступки — б-я ч и, заполняющие нек-рую область около синхротронных значений фазы. Макс. число ступок на орбите равно q .

Траектория частиц в С. з. изгибается с помощью дипольных магнитов, создающих ведущее (поворотное) магн. поле. Для фокусировки частиц в совр. С. з.

Основные параметры некоторых действующих протонных синхротронов

Место размещения и название	СССР, Серпухов, ИФВЭ	Япония, КЕК	Швейцария, СРС (SPS)	США, тэватрон
Время начала строительства, год	1961	1971	1970	1979
Первый пучок (фактически или по плану), год	1967	1976	1976	1983
Энергия, ГэВ	76	12	450	800
Частота обращения, цикл/с	0,4	0,4	0,4	1/80
Интенсивность пучка, сист./цикл	$1,7 \cdot 10^{10}$	$4 \cdot 10^{10}$	$3,8 \cdot 10^{10}$	2000
Диаметр кольца, м	236,3	108	2200	ФОДО
Структура периода фокусирующей системы	ФОДО	ФОДО	ФОДО	ФОДО
Бетатронная частота	9,85 9,8	7,11 7,22	25,6 26,8	18,42 18,41
Число магнитов	120	48	744	744
Магн. индукция (при инжекции, Тл)	0,038	0,15	0,083	0,66
Магн. индукция (максимальная, Тл)	1,2	1,75	5,025	4,4
Ср. мощность питания магн. системы, МВт	40	4	4	8
Число резонаторов	30	9	4620	1113
Кратность гармоник	5,5—6,1	6,03—7,93	199,4—200,4	53,1
Диапазон изменения частоты, МГц	170 × 115	145 × 50	150 × 150	75 × 75
Ср. мощность ВЭ-системы, МВт	3—4 · 10 ⁻⁷	1 · 10 ⁻⁷	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰
Апертура вакуумной камеры, мм				
Ср. давление, торр				

рением частиц, появляемся при искривлении их траекторий в магн. поле. Аналогичное излучение релятивистских частиц, движущихся по круговым или спиральным траекториям, наз. циклотронными и излучением; оно происходит на осн. гиромагн. частоте и её первых гармониках. С увеличением скорости частицы роль высоких гармоник возрастает; при приближении к релятивистскому пределу излучение в области наиб. интенсивных высоких гармоник обладает практически непрерывным спектром и сосредоточено в направлении мгновенной скорости частицы в узком конусе с углом раствора $\varphi \approx mc^2/\mathcal{E}$, где m — масса покоя, \mathcal{E} — энергия частицы.

Полная мощность излучения частицы с энергией $\mathcal{E} \gg mc^2$ равна

$$-\frac{d\mathcal{E}}{dt} \approx \frac{2\pi^2}{3mc^2} H_1^2 \mathcal{E}^2 = 0,98 \cdot 10^{-9} H_1^2 \left(\frac{\mathcal{E}}{mc^2}\right)^2 \text{ (эВ/с)},$$

где e — заряд частицы, H_1 — составляющая магн. поля, перпендикулярная её скорости. Т. к. излучаемая мощность сильно зависит от массы частицы, С. и. наиб. существенно для лёгких частиц — электронов и позитронов. Спектральное (по частоте ν) распределение излучаемой мощности определяется выражением

$$P(\nu) = \frac{\sqrt{3}e^2 H_1}{mc^2} \cdot \frac{\nu}{v_0} \int_{\nu/v_0}^{\infty} K_2(\eta) \eta^3 d\eta,$$

где $v_0 = (3eH_1/4\pi mc)(\mathcal{E}/mc^2)^2$, а $K_2(\eta)$ — цилиндрич. ф-ция второго рода мнимого аргумента. Характерная частота, на к-рую приходится максимум в спектре излучения частицы:

$$\nu[\Gamma] \approx 0,29v_0 = 1,8 \cdot 10^{18} H_1 \mathcal{E}^2 [\text{эВ}].$$

Излучение отд. частицы в общем случае эллиптически поляризовано, причём большая ось эллипса поляризации расположена перпендикулярно видовой проекции магн. поля. Степень эллиптичности и направление вращения вектора напряжённости электр. поля зависят от направления наблюдения по отношению к конусу, описываемому вектором скорости частицы вокруг направления магн. поля. Для направлений наблюдения, лежащих на этом конусе, поляризация излучения линейная.

Первые С. и. предсказано А. Шоттом (А. Schott, 1912) и наблюдалось в циклич. ускорителях электронов (в синхротроне, поэтому и получило назв. С. и.). Потери энергии на С. и., а также связанные с С. и. квантовые эффекты в движении частиц необходимо учитывать при конструировании циклич. ускорителей электронов высокой энергии. С. и. циклич. ускорителей электронов используется для получения итронивных лучков поляризов. эл.-магн. излучения в УФ-области спектра и в области «мягкого» рентг. излучения; пучки рентг. С. и. применяются в рентгеновском структурном анализе, рентг. спектроскопии и др.

Большой интерес представляет С. и. космич. объектов, в частности тепловых радиониф Галактики, тепловое радио- и оптич. излучение дискретных источников (сверхновых звёзд, пульсаров, квазаров, радиогалактик). Синхротронная природа этих излучений подтверждается особенностями их спектра и поляризации. Релятивистские электроны, входящие в состав космич. лучей, в космич. магн. полях дают синхротронную составляющую космич. излучения в радио-, оптич. и рентг. диапазонах. Измерения спектральной интенсивности и поляризации космич. С. и. позволяют получить информацию о концентрации и энергетич. спектре релятивистских электронов, величине и направлении магн. полей в удалённых частях Вселенной.

Лит.: Соловьев А. А., Теряев И. М. Релятивистские электроны. М., 1974; Кудряшов В. Н., Свирицкий А. Н., Использование синхротронного излучения: состояние и перспективы, «УФН», 1977, т. 122, в. 3; Синхротронное излучение. Свойства и применения, пер. с англ., М., 1981.

С. И. Смирновский.

СИНХРОТРОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ — колебания энергии и фазы (импульса и фазы, координаты и фазы) ускоренных частиц при резонансном ускорении в линейных и циклич. ускорителях; в теории циклич. ускорителей наз. также *радиально-фазовыми колебаниями* (под фазой здесь понимается фаза, к-рую имеет ускоряющее ВЧ-поле в момент прихода частиц в ускоряющий промежуток). На С. к. впервые обратили внимание В. И. Векслер и Э. Мак-Миллан (Е. McMillan), сформулировавшие принцип *автофазировки* — наличия устойчивого (равновесного) значения фазы при любом стабильном режиме резонансного ускорения в кольцевых ускорителях.

На плоскости \mathcal{E} , φ (энергия, фаза) среди обширных областей неустойчивого движения выделяются ограниченные сепаратрисами островки устойчивости, расположенные вокруг равновесных значений \mathcal{E}_p и φ_p этих величин (индекс p указывает на равновесные значения энергии, импульса, скорости и фазы). Энергия и импульс частиц при ускорении возрастают; поэтому \mathcal{E}_p и φ_p являются ф-циями времени. Равновесная фаза φ_p в зависимости от режима ускорения может либо изменяться, либо оставаться неизменной. Подобные области устойчивости образуются на плоскостях r , φ и r , φ .

В *линейных ускорителях* об устойчивости фазового движения приходится специально заботиться, т. к. одновременно стабильность поперечного (бетатронного) и продольного (синхротронного) движения частиц возникает не при всех ускорит. структурах.

В кольцевых ускорителях характер фазового движения существенно зависит от величин

$$\alpha_p = 1/\eta^2 - \alpha, \quad (1)$$

где $\eta = \mathcal{E}/mc^2$ — лоренц-фактор частицы (\mathcal{E} — полная энергия частицы, включающая энергию покоя mc^2), $\alpha = d(\ln\Pi/d \ln p)$ — коэф. расширения орбит (Π — периметр орбиты). В ускорителях с $\alpha > 1$ устойчивость С. к. имеет место при любых энергиях. К числу таких ускорителей относятся все ускорители со слабой фокусировкой (см. *Фокусировка частиц в ускорителе*). В ускорителях с сильной фокусировкой коэф. расширения орбит чаще всего оказывается равным небольшой положительн. величине (при обычных структурах магн. системы $\alpha \approx 1/Q^2$, где Q — число бетатронных колебаний на оборот). При увеличении энергии α_p обращается в нуль, а затем меняет знак. Энергия частиц, при к-рой α_p обращается в нуль, в отеч. литературе наз.

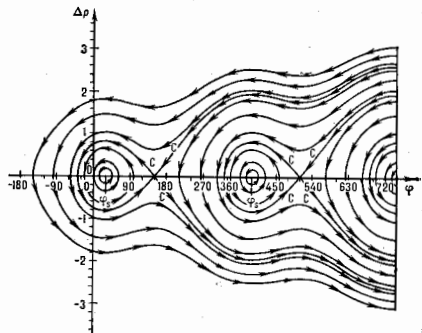


Рис. 1. Синхротронное движение до критической энергии для $\varphi_p = 30^\circ$. Отклонения по импульсу Δp изображены в произвольном масштабе (С — сепаратрисы).

критической, в английской — переходной энергией (transition energy).

Характер С. к. до и после критич. энергии показаны рис. 1 и 2. На графиках чётко выделяются вакуумные фазовые траектории в области устойчивого движения.

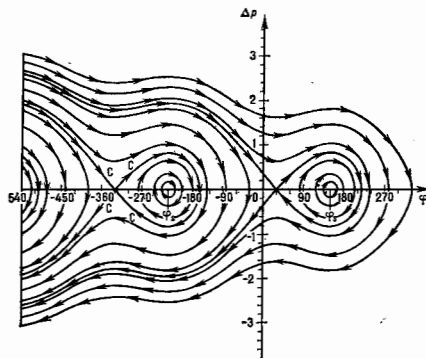


Рис. 2. Синхронное движение после критической энергии, $\varphi_c = 150^\circ$.

Синхронная фаза и синхронные значения энергии, импульса и скорости v_s определяются темпом ускорения частиц и амплитудой ускоряющего напряжения. Частицы сохраняют своё радиальное положение в кольцевых ускорителях, если выполняется соотношение

$$rc = eBR, \quad (2)$$

где B — магн. индукция поля, R — радиус кривизны траектории, e — заряд частицы. Темп возрастания $H(t)$ при постоянном R задаёт необходимую скорость увеличения импульса, а следовательно, и энергии. С др. стороны, прирост энергии за оборот равен $eV \sin \varphi$, где V — суммарное напряжение ускоряющих станций. Т. о. при заданном V определяется значение $\sin \varphi$, и, следовательно, два стационарных значения фазы: φ_s и $\pi - \varphi_s$. Одно из них всегда оказывается устойчивым, другое — неустойчивым. В критич. точке устойчивое и неустойчивое значения фазы меняются местами.

С. к. нелинейны. Их принято характеризовать энергией. (или импульсной) шириной сепаратрисы и частотой малых С. к. ω_c :

$$\omega_c = \omega_p \sqrt{q e V \omega_p \cos \varphi_s / 2 \pi p v_s}, \quad (3)$$

ω_p — частота обращения частиц, q — кратность частоты ускорения — целое число, равное отношению ускоряющей частоты к частоте обращения.

При критич. энергии частота С. к. обращается в нуль и движение частиц испытывает ряд особенностей: они собираются в узкие струйки и приобретают большой разброс по энергии. В этой точке фаза ускоряющего напряжения должна быть изменена на φ на $\pi - \varphi_s$. Вдали от критич. точки амплитуда колебаний частиц по фазе уменьшается как $e^{-1/4}$.

Лит. см. при ст. *Синхротрон электронами*.

Л. Л. Гольдман, Д. В. Пестриков.

СИНХРОФАЗОТРОН — выходящее из употребления название протонного синхротрона со слабой фокусировкой (см. *Синхротрон протонный*).

СИНХРОЦИКЛОТРОН — то же, что *фазотрон*.

СИРЕНА — механич. устройство для создания мощных акустич. колебаний, действие к-рых основано на прерывающемся высокоскоростном струй, вытекающих через отверстия. По типу рабочего тела, используемого в С., выделяют С. газовые (воздушные) и жидкостные, по принципу работы — роторные (вращающиеся) и пульсирующие, по характеру создаваемого ими акустич. сигнала — тональные и широкополосные. В роторных С. струя прерывается в результате вращения ротора (с помощью электромотора или газовой турбины) относительно статора, при к-ром отверстия ротора то совмещаются с отверстиями статора, то перекрываются. В пульсирующих С. колеблющаяся заслонка с отверстиями приводится в возвратно-поступат. движение электромехан. преобразователем, питаемым от звукового генератора.

Для получения тонального акустич. сигнала отверстия в роторе и статоре должны иметь одинаковые размеры и располагаться на равных расстояниях друг от друга. В широкополосных С. отверстия выполняются разных форм и размеров и располагаются по ротору и статору неравномерно; иногда применяются неск. роторов, расположенных друг за другом и вращающихся с разными скоростями. Тональные воздушные С. используются в осн. как акустич. излучатели для сигнализации, жидкостные — для интенсификации реакт. процессов путём ускорения теплообмена за счёт закомперированных пульсаций среды и возникновения в ней *кавитации*. Широкополосные С. служат гл. обр. для шумовых испытаний оборудования на долговечность. Осн. частота тональной С. определяется числом прерываний струи в 1 с и, следовательно, пропорциональна числу отверстий в роторе или статоре к числу оборотов ротора за 1 с. Частотный диапазон применяемых на практике С. составляет от 200—300 Гц до 100 кГц.

Ротор и статор жидкостных С. обычно выполняют в виде полых цилиндров или конусов, газowych — в виде дисков (осевые С.) или цилиндров (радиальные С.). Кнд С. зависит от формы используемых отверстий, а также от зазора между ротором и статором; у лучших образцов он достигает 50—60% при калучаемой мощности в неск. кВт.

Ю. А. Борисов.

СИСАМ (спектрометр интерференционный с селективной амплитудной модуляцией) — спектральный прибор, построенный на основе двухлучевого *интерферометра Майкельсона*, в к-ром концы зеркала замещены синхронно поворачивающимися дифракц. решётками и введён модулятор по оптич. разности хода. См. *Спектральные приборы*.

СИСТЕМА ЕДИНИЦ физических величин — совокупность основных и производных единиц нек-рой системы физ. величин, образованная в соответствии с принятыми принципами построения этой системы. С. е. строится на основе физ. теорий, отражающих существующую в природе взаимосвязь физ. величин. С целью выбора единиц системы подбирается такая последовательность физ. соотношений, в к-рой каждая следующая содержит только одну новую физ. величину. Это позволяет определить единицу физ. величины через совокупность ранее уже введенных единиц, в конечном счёте — через основные (независимые) единицы системы (см. *Единицы физических величин*). Связь производных единиц системы выражается ф-лами размерности. Обычно в качестве основных выбирают единицы, к-рые могут быть воспроизведены эталонами или эталонными установками, с наивысшей для существующего уровня развития науки и техники точностью.

В первых С. е. в качестве основных были выбраны единицы длины и массы (напр., в Великобритании фут и англ. фунт, в России — аршин и рус. фунт). Неудобство, вызываемое различием и сложностью национальных С. е., привели к разработке метрич. системы мер (18 в., Франция) и к созданию на её основе международн. унификации единиц длины (метр) и массы (килограмм).

В сер. 19 в. К. Ф. Гаусс (С. F. Gauß) и В. Вебер (W. Weber) предложили С. е. для электр. и магн. величин (абсолютная, или Гаусса система единиц). В качестве осн. единиц в ней приняты миллиметр, миллиграмм и секунда; производные единицы образовывались по ур-ниям связи между величинами в простейшем их виде, т. е. с числовыми коэф., равными единице (такие С. е. позднее получили назв. когерентных). Во 2-й пол. 19 в. Британская ассоциация по развитию наук приняла две С. е. с осн. единицами сантиметр, грамм, секунда: электростатическую (СГСЭ) и электромагнитную (СГСМ) (см. СГС система единиц). Затем были приняты техническая С. е. (или МКГСС С. е.) с осн. единицами метр, килограмм-сила, секунда и МТС С. е. с осн. единицами метр, тонна, секунда. В 1901 Дж. Джорджи (G. Giorgi) предложил С. е. с осн. единицами метр, килограмм, секунда и одной электр. единицей (кулон). Эта С. е. была положена в основу Международной системы единиц (СИ), принятой в 1960 на 11-й Генеральной конференции по мерам и весам. В СИ приняты 7 осн. единиц — метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль. На СИ перешли все страны, она позволила унифицировать и упростить систему измерений в науке и технике.

Наряду с практич. С. е. в физике применяются системы, в основу к-рых положены фундаментальные физические константы.

Лит.: Бурдуи Г. Л., Единицы физических величин, 4 изд., М., 1967; его же, Справочник по Международной системе единиц, 3 изд., М., 1980; Стоцкий Л. Р., Физические величины и их единицы, М., 1984; Сеня Л. А., Единицы физических величин и их размерности, 3 изд., М., 1989.

СИСТЕМА ОТСЧЕТА — совокупность системы координат в часов, связанных с телом, по отношению к-рому изучается движение (или равновесие) к-л. др. материальных точек или тел. О способах задания движения точки или тела по отношению к выбранной С. о. и об определении кинематич. характеристик этого движения см. в ст. *Кинематика*. Выбор С. о. зависит от целей исследования и, вообще говоря, произволен. При кинематич. исследованиях все С. о. равноправны. В задачах динамики также могут использоваться любые произвольно движущиеся С. о. Однако по многих случаях преимущество роль играют *инерциальные системы отсчета*, по отношению к к-рым дифференц. ур-ния движения имеют обычно более простой вид. Иногда, напр. при исследовании процессов в к-л. среде, удобно выбрать С. о., движущуюся вместе со средой. Такая С. о. наз. *сопутствующей*.

СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (распределенная система) — система пространственные масштабы движения в к-рой соразмерны с пространственными масштабами измененная физ. параметр. Термин «С. с р. п.» возник при становлении проводной телеграфии для характеристик длинн. передач как системы, в к-рой длина эл.-магн. волны сравнима с длиной самой системы (линии). Для описания процессов в таких линиях, по аналогии с системами с сосредоточенными параметрами (элементами), оказалось удобным введение распределенных элементов — погонной ёмкости, индуктивности и проводимости. Термин «С. с р. п.» используется в более широком смысле, в частности применительно к системам с волновыми движениями реал. физ. природы.

Понятие С. с р. п. не абсолютно, одни и те же системы по отношению к разным движениям могут выступать как С. с р. п. и как системы с сосредоточенными параметрами. Напр., колебания пружины на сравнительно низких частотах могут быть с достаточной точностью представлены как движение в системе с сосредоточенными параметрами, когда все звенья пружины ведут себя идентично. С ростом частоты колебаний пружина перестаёт сжиматься и растягиваться как единое целое — по ней побегут волны с пространственными масштабами (длинной волны λ), соразмерными или даже много меньшими длинн. пружины, и пружина начнёт вести

себя как система с распределённой массой и упругостью. Др. примером может служить плоский (для простоты) конденсатор сзором d и площадью пластин S . В квазистатич. эл.-магн. полях ($\lambda \gg d, \sqrt{S}$) — это система с сосредоточенными параметрами, характеризуемая по отношению к внеш. цепи одним параметром — ёмкостью. При этом структура электр. поля внутри конденсатора почти однородна (идеально от краёв пластин) и не зависит от λ . При $\sqrt{S} \lesssim \lambda \lesssim d$ оказывается возможным распространение modes пластин эл.-магн. волн, т. е. конденсатор превращается в «длинную» полосу-линию (см. *Линии передачи*) с распределёнными параметрами: погонными ёмкостью, индуктивностью и проводимостью. Наконец, при $\sqrt{S} \ll d$ это уже квазиоптический *открытый резонатор* типа резонатора Фабри — Перо.

В линейных консервативных С. с р. п., где потери энергии (в т. ч. и на излучение) и притоки её извне отсутствуют, произвольное движение сводится к бесконечному, по счёту множеству нормальных колебаний, каждое из к-рых можно интерпретировать как состояние нек-рой системы с сосредоточенными параметрами (а том смысле, что нормальное колебание, как и эта система, описывается с помощью обыкновенных дифференц. ур-ний). В неконсервативных и нелинейных С. с р. п. такое двойственное описание, вообще говоря, невозможно. Подробнее см. в ст. *Колебания, Волны, Автоколебания, Нормальные колебания, Моды*.

Лит.: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике. [пер. с англ.], 3 изд., т. 1—4, М., 1977; Мандельштам Л. И., Лекции по теории колебаний, М., 1972; Козловский А. И., Миллер.

СИСТЕМА С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (дискретная система) — система, движение к-рой может быть описано как движение конечного числа точечных объектов (строго сосредоточенные параметры) или протяжённых объектов с жёстко фиксированной внутр. структурой (параметры, сводимые к сосредоточенным). Напр., тело, подвешенное на нити (маятник), относится к С. с р. п., если его можно считать точечным, а нить — нерастяжимой и невесомой; колебат. контур, состоящий из индуктивности L , ёмкости C и сопротивления R , является С. с р. п., когда размеры всех его элементов значительно меньше длинн. эл.-магн. волны и структуру полей в элементах L , C и R можно идеализировать как жёстко фиксированную.

Описание движения С. с р. п. обычно основывается на ур-ниях, связывающих обобщённые координаты и обобщённые импульсы (в т. ч. поля, токи, напряжения) входящих в неё объектов. Порядок этих ур-ний определяется числом степеней свободы С. с р. п. Так, плоское движение маятника в поле тяжести с п.ч. изменением тока в L , C , R -контуре описывается дифференц. ур-ниями 2-го порядка и соответствует С. с р. п. с одной степенью свободы. Ур-ния движения консервативных (сохраняющих энергию) С. с р. п. имеют вид получаемых на вариац. принципе (см. *Наименьшее действие принцип*). При этом выделяют три осн. типа эквивалентных описаний движения С. с р. п.: через Лагранжана ф-цию, содержащую обобщённые координаты и скорости, через Гамильтонана ф-цию, содержащую обобщённые импульсы и координаты, и через ф-цию действия (см. *Гамильтонана — Якоби уравнение*), выраженную через обобщённые координаты и их производные. В первых двух случаях в ур-ния входят полные производные по времени, в последнем случае — частные производные.

Лит.: А и пр о в а. А., В и т т. А. А., Х а в и н с. В., Теория колебаний, 3 изд., М., 1981; Д а н д а у. Д. Д., Л и ф ш и ц. Е. М., Механика, 4 изд., М., 1988; М а н д е л ь с т а м Л. И., Лекции по теории колебаний, М., 1972.

М. А. Миллер.

СКАЛЯРНАЯ ЧАСТИЦА — элементарная частица, характеризующаяся нулевым спином и положительной внутренней чётностью. В квантовой теории поля С. ч. являются квантами скалярного поля. Примеры С. ч. — f_0 и a_0 -мезоны, а также гипотетический *Хиггса бозон*.

СКАЛЯРНОЕ ПОЛЕ — поле физической, к-рое описывается ф-цией координат пространственно-времени $x = (x, t)$, не меняющейся при поворотах системы координат. Свободные (невозмущающие) поля подчиняются *Клейна — Гордона уравнению*

$$(\square + m^2)\varphi(x) = 0, \quad (*)$$

где $\square = D^2$ *Алампера оператор*, а параметр m наз. массой (ур-ние записано в системе $\hbar = c = 1$). Общее решение (*) имеет вид суперпозиции плоских волн с волновым вектором k и частотой $k_0 = \sqrt{k^2 + m^2}$ (нулевой компонентой 4-вектора k):

$$\varphi(x) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{-3/2} \int \frac{d^4k}{\sqrt{2k_0}} [a^+(k)e^{ikx} + a^-(k)e^{-ikx}].$$

В квантовой теории поля ф-ция $a^{\pm}(k)$ представляют собой операторы рождения и уничтожения свободных скалярных частиц с импульсом k , массой m и нулевым спином, являющихся квантами С. п. Для взаимодействующего С. п. в правой части ур-ния (*) стоит выражение, нелинейно зависящее от самого поля $\varphi(x)$ (случай самодействия), напр.: $g\varphi^2(x)$, где g — константа взаимодействия) или от др. физ. полей. По поведению относительно пространственной инверсии С. п. делат на собственно скалярные $[\varphi(-x) = \varphi(x)]$ и псевдоскалярные $[\varphi(-x) = -\varphi(x)]$. Отвечающие им элементарные частицы имеют соответственно положительную и отрицательную внутреннюю чётность и наз. скалярными частицами и псевдоскалярными частицами (напр., π, K, η, η').

А. В. Ефремов.

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ — отображение, сопоставляющее каждой паре e_1, e_2 векторов к-л. векторного пространства L нек-рое число (e_1, e_2) , причём выполняются след. условия: а) $(e_1, e_1) = (e_1, e_2)^*$ (* означает комплексное сопряжение); б) $(e_1, \lambda e_1' + \lambda' e_2') = \lambda(e_1, e_1') + \lambda'(e_1, e_2')$; в) $(e, e) \geq 0, (e, e) = 0$ лишь при $e = 0$. Из этих аксиом следует неравенство Коши — Буняковского — Шварца

$$|(e_1, e_2)| \leq \sqrt{(e_1, e_1)(e_2, e_2)}$$

и антилинейность С. п. по первому аргументу, т. е.

$$(\lambda e_1' + \lambda' e_2', e_2) = \lambda^* (e_1', e_2) + \lambda'^* (e_2', e_2).$$

С.п. порождает в L и орму, т. е. операцию, сопоставляющую каждому вектору e вещественное неотрицательное число $\|e\|$, к-рое служит обобщением понятия длины вектора $e, \|e\| = \sqrt{(e, e)}$. Т. о., пространство L оказывается нормированным n -м. Нормы задаёт топологию пространства L , т. е. определяет в нём понятие близости: последовательность $e_1, e_2, \dots, e_n, \dots$ векторов считается сходящейся к вектору e , если $\|e_n - e\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Пространство L наз. п. о. л. n , если любая последовательность векторов e_1, \dots, e_n, \dots (такая, что $\|e_n - e_m\| \rightarrow 0$ при $n, m \rightarrow \infty$) имеет предел e , являющийся вектором того же L . Если $(e_1, e_2) = 0$, то векторы e_1 и e_2 наз. ортогональными n . Если $\|e\| = 1$, то вектор наз. нормированным. Совокупность e_1, e_2, \dots, e_n наз. ортонормированной системой векторов, если она состоит из нормированных, попарно ортогональных векторов.

Конечномерное пространство L , снабжённое С. п., наз. *евклидовым пространством*. Если L является бесконечномерным и полным, то оно наз. *гильбертовым пространством*. С. п. (e_1, e_2) где вектор e_1 фиксирован, а вектор e рассматривается как переменная, определяет члусловую ф-цию $f(e) = (e_1, e)$ на гильбертовом пространстве. Эта ф-ция линейно зависит от e и обладает свойством непрерывности (если $e \rightarrow e_0$, то $f(e) \rightarrow f(e_0)$), её называют *линейным функционалом*.

В гильбертовом пространстве всякой линейной функционал $f(e)$ порождается С. п., т. е. всегда найдётся такой вектор e_1 , что $f(e) = (e_1, e)$.

Лит.: Дирак П. А. М., *Принципы квантовой механики*, пер. с англ., 2 изд., М., 1978; Кострикин А. И., Матрица Ю. И., *Линейная алгебра и геометрия*, 2 изд., М., 1968. О. И. Зильберс.

СКАЛЯРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ — скалярная ф-ция, описывающая безвихревые (потенциальные) векторные поля. В общем случае n -мерного пространства эта ф-ция л. переменных (координат). В трёхмерном пространстве безвихревыми (потенциальными) являются векторные поля $a(r)$, удовлетворяющие условию $\nabla \times a(r) = 0$; они могут быть представлены в виде $a(r) = -\nabla\varphi(r)$. Величина $\varphi(r)$, определяемая полем $a(r)$ с точностью до произвольной постоянной, наз. С. п. векторного поля $a(r)$.

Первые С. п. был введён как потенциал ньютоновского поля тяготения распределённой гравитирующей массы, затем стал применяться как потенциал обобщённой силы а лагранжевой механике. В связи с этим для характеристики любых физ. полей часто используют понятия, заимствованные из механики, такие, как потенц. рельеф, потенц. яма, потенц. барьер и т. п.

Общую роль С. п. играет в теории эл.-магн. поля, где вместе с *векторным потенциалом* он позволяет получить полное описание эл.-магн. поля. В некоторых случаях статических эл.-магн. полей С. п. используется независимо от векторного потенциала. Так, электростатич. поле $E(r)$ является потенциальным ($\nabla \times E = 0$) и описывается электростатическим С. п. $\varphi(r)$: $E = -\nabla\varphi$. В среде с заданным распределением *диэлектрической проницаемости* $\epsilon(r)$ электрич. С. п. удовлетворяет ур-нию $\nabla(\epsilon\nabla\varphi) = -4\pi\rho$, где ρ — объёмная плотность сторонних электрич. зарядов. В однородных средах $\epsilon(r) = \text{const}$ это ур-ние сводится к *Пуассона уравнению*, а в областях, свободных от зарядов ($\rho = 0$), — к *Лапласа уравнению*. Решения ур-ний для С. п. существенно зависят от распределения сторонних и связанных электрич. зарядов, а также от граничных условий. Выбирая распределение $\varphi(r)$, можно получать любые распределения С. п. $\varphi(r)$ — любые потенц. рельефы. В областях пространства, свободных от источников поля, распределение С. п. не может иметь абс. минимум или максимумов (см. *Ирришу теорема*). Для нек-рых сферических симметричных распределений С. п. существуют собственные имена; так, С. п. вида $1/r$ наз. кулоновским потенциалом, С. п. вида $(1/r)\exp(-r/a)$, где $a = \text{const}$, наз. добавским потенциалом (иногда потенциалом Дебая — Хюккеля).

В областях пространства, где отсутствуют сторонние электрич. токи, статич. магн. поле $H(r)$ также является потенциальным ($\nabla \times H = 0$) и может быть описано при помощи магн. С. п.: $H = -\nabla\varphi^M$. Особенно удобно использовать магн. С. п. при расчётах магн. полей, создаваемых постоянными магнитами; С. п. при этом подчиняется ур-нию Пуассона

$$\Delta\varphi^M = 4\pi I \cdot M,$$

где M — заданная сторонаняя намагниченность. Использование этого ур-ния для φ^M эквивалентно введению эфф. «магн. зарядов» с объёмной плотностью $\rho^M = -\nabla \cdot M$.

Лит. см. при ст. *Максвелла уравнения*.
М. А. Мильер, Е. В. Свирев.
СКАНДИЙ (Scandium), Sc, — хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 21, ат. масса 44,95591, редкоземельный элемент. В природе представлен одним стабильным нуклидом ^{45}Sc . Конфигурация внеш. электронных оболочек $3d^2 4s^2 4p^6$. Энергия последоват. ионизации 6,562; 12,80; 24,75; 74,2; 93,9 эВ соответственно. Радиус атома 0,164 нм, радиус иона Sc^{3+} 0,083 нм. Значение электроотрицательности 1,20. В свободном виде мягкий серебристый металл с жёлтым оттенком, в интервале темп-р от комнатной до

1336 °C устойчив α -Sc с гексагональной решёткой, параметры k -рой $a = 0,33080$ и $c = 0,52653$ нм; при темп-рахе от 1336 °C до $T_{пл} = 1541$ °C существует β -Sc с объёмноцентрированной, кубич. решёткой, параметр k -рой $a = 0,4541$ нм. Плотность α -Sc 3,020 кг/дм³, $k_{пл} = 2850$ °C, теплоёмкость $c_p = 25,5$ Дж/(моль·K), теплота плавления 14,1 кДж/моль, теплота испарения 315 кДж/моль. Темп-ра Дебая 231 К. Уд. электрич. сопротивление 0,64 мкОм·м (при 20 °C), термич. коэф. электрич. сопротивления 2,463 · 10⁻³ K⁻¹ (при 25—100 °C). Слабый парамагнетик, магн. восприимчивость α -Sc 0,177 · 10⁻⁹ Термич. коэф. линейного расширения 1,14 · 10⁻⁴ K⁻¹ (при 400 °C). Теплопроводность 15,5 Вт/(м·K) (при 18 °C). Твёрдость по Бринеллю С. чистотой 99% 750—1000 МПа, модуль нормальной упругости при растяжении отожжённого С. чистотой 99,1% 77 ГПа, модуль сдвига 31,9 ГПа. Химически активен, особенно при повыш. темп-рах. В соединениях проявляет степени окисления +3 и +2 (реже).

С. применяется как компонент лёгких коррозионноустойчивых сплавов, как нейтронный фильтр в ядерной физике. Оксид Sc₂O₃ используют при изготовлении скандиевого феррита для элементов памяти ЭВМ. Как радиоакт. индикатор применяют ⁴⁶Sc (β -распад, $T_{1/2} = 783,783$ сут), его используют также в медицине.

С. С. Вербонов.

СКАНЕРЫ — устройства для управления направлением светового луча в пространстве на основе явления акустооптики, дифракции (см. *Акустооптика*); представляют собой НЧ-приборы ($f \leq 0,5$ МГц), осуществляющие равертку светового луча по синусоидальному закону.

СКАНИРОВАНИЕ в радиолокации — угловое перемещение *диаграммы направленности* (ДН) антенны, в случае остроуправленных систем — её луча. Наиб. простым (но надёжным) способом С. ДН является механич. изменение ориентации антенны, широко применяемое в радиолокац. и радионавигац. устройствах. Существуют, однако, и методы электрич. управления ДН, или С. Обычно их классифицируют по типу изменяемого параметра (амплитуда, фаза или частота) распределения токов на апертуре антенны. Особо выделяется частотное С., поскольку оно реализуется только для систем с достаточно сильной дисперсией ДН, т. е. зависимость её формы и ориентации от несущей частоты сигнала. В случае передающих антенн (излучателей) в результате изменения амплитуд, фаз или частот должно осуществляться действит. перемещение направления излучения. Для приёмных антенн перемещение направления луча может быть следствием обработки принимаемого сигнала, напр. путём приёма только определ. образом сфазированных компонент сигнала в многоэлементных антеннах. Такого типа С. часто используется в пассивной локации и *радиоастрономии* (в частности, в системах *апертурного синтеза*). С. применяется в радионастроении при обзорах небесной сферы (при наблюдениях врезанных объектов для С. может использоваться также вращение Земли), в радиометеорологии при исследованиях пространственного распределения яркостной темп-ры для получения метеоданных (напр., о высотном профиле темп-ры, распределении водяного пара, скоростей ветра), в пассивной радиолокации для радиокартографирования поверхности Земли и планет, в радиолокации для обнаружения, идентификации и сопровождения разл. объектов. С. служит иногда и для улучшения характеристик приёмных систем: повышения чувствительности (модуляц. метод приёма с «качаем луча»), разрешения (напр., создание разностной ДН для точного определения т. н. равнонаправленного направления), помехозащищённости (напр., компенсация, исключение влияния распределённого радиоизлучения).

Лит. см. при ст. *Антенна, Апертурный синтез*.

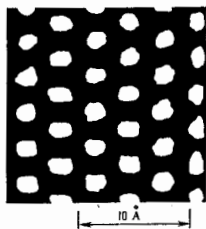
СКАНИРУЮЩИЙ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОП — прибор для изучения поверхностей твёрдых

тел с разрешающей способностью порядка межатомных расстояний, оснований на сканировании исследуемого участка образца $S(x, y)$ плоской пружиной, свободный конец k -рой (или укреплённый на пём острей) удалён от поверхности образца на расстояние z в неск. А. Изобретён Г. Биннингем (G. Binnig), К. Ф. Куатом (C. F. Quate) и К. Гербером (C. Gerber) в 1986. При таких расстояниях сила взаимодействия между двумя ближайшими атомами, расположенными соответственно на кончике острья и на поверхности образца, составляет $10^{-7} - 10^{-9}$ Н. При жёсткости упругого элемента порядка 1 Н/м это приводит к измеримой деформации пружины. При сканировании цепь обратной связи поддерживает деформацию пружины (и тем самым силу взаимодействия), соответственно изменяя z . Связанная со сканированием запись сигнала обратной связи U_z представляет собой запись профиля поверхности пост. слой $F(x, y)$, т. е. фактически поверхности образца.

Т. к. силы взаимодействия между атомами острья и поверхности быстро спадают с расстоянием (для сил притяжения типа Ван-дер-Ваальса при взаимодействии двух атомов как z^{-7} , для сил отталкивания при потенциале Ленарда — Джонса как z^{-13} ; см. *Межатомное взаимодействие, Межмолекулярное взаимодействие*), то разрешающая способность С. а. с. м. может достигать 0,001 нм по z и 0,1 нм по x, y . Прибор может работать в вакууме и жидкости, значительно хуже — при обычных атм. условиях, когда поверхностные плёнки влаги приводят к слипанию кончика упругого элемента с поверхностью образца, к росту действующих между ними сил F на неск. порядков и к значит. гистерезису зависимости $F(z)$.

Устройство С. а. с. м. во многом аналогично устройству *сканирующего туннельного микроскопа*. Принципиальным отличием является то, что стабилизирующ

Изображение поверхности скола графита — плоскость (0001). Максимальные зазоры урони от светлого к тёмному — 0,015 нм.



не ток между острейм и образцом, а деформация чувств. элемента. Для её измерения в первых С. а. с. м. использовалось измерение туннельного тока между тыльной (по отношению к образцу) стороной плоской пружины и подводящим к ней дополнит. электродом — острейм; применяются также оптич. методы, основанные на наблюдении интерференции или отклонения луча света, отражающегося от чувств. элемента. С. а. с. м. можно преобразовать в прибор для зондирования магн. полей с субмикронным разрешением; при этом на кончике пружины закрепляется крупинка ферромагн. материала. Другие области применения те же, что и для сканирующей туннельной микроскопии. Преимущество С. а. с. м. — возможность изучения (с атомным разрешением) поверхности не только проводников, но и диэлектриков (рис.).

Лит. см. при ст. *Сканирующий туннельный микроскоп, В. С. Зельман*.

СКАНИРУЮЩИЙ ТУННЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП — прибор для изучения поверхности твёрдых электропроводящих тел, основанный на сканировании металлических острья над поверхностью образца на расстоянии

$z \approx 3-10 \text{ \AA}$. Такое расстояние достаточно мало для туннелирования электронов через контакт, т.е. для протекания туннельного тока $j \approx 1-10 \text{ нА}$ между острием и образцом, при разности потенциалов V между ними от единиц мВ до кВ. V (в зависимости от материалов электродов и щелей). При этом цепь обратной связи поддерживает значение j постоянным, соответственно изменяя z . Сканирующая со сканированием запись сигнала обратной связи V_2 (на двухкоординатном самописце — в виде кривых, на экране телевиз. трубки — в виде карты и т. п.) представляет собой увеличенную запись профиля поверхности постоянного туннельного тока $j(x, y)$. Она совпадает с геом. поверхностью образца $S(x, y)$, если высота потенц. барьера (работа выхода) электронов ϕ одинакова по всей поверхности S , поскольку $j = j_0 \exp(-A\phi^{1/2})$, где $A \approx 1 \text{ \AA}^{-1} (eV)^{1/2}$. В ином случае распределение $\phi(x, y)$ может быть получено путем модуляции расстояния на частоте, более высокой, чем скорость пропускания цепи обратной связи и измерения возникающей на этой частоте модуляции j , амплитуда к-рой пропорциональна $\phi^{1/2} = d\ln j/dz$. Т. о., в результате сканирования острья над участком исследуемой поверхности получатся одновременно её профиль $S(x, y)$ и распределение работы выхода $\phi(x, y)$.

С. т. м. изобретён Г. Биннингом и Г. Рорером в 1982 [1]. Увеличение его определяется отплением размеров записи кадра (на бумаге или экране трубки) и размерам сканируемого участка поверхности, последние могут составить от единиц Å до десятков мкм. Разрешающая способность микроскопа по x, y достигает $\sim 1 \text{ \AA}$, а по z порядка $0,01 \text{ \AA}$. Прибор может работать в вакууме, газе или жидкости, поскольку z имеет величину порядка межатомных расстояний в жидкости. Выбор среды определяется конкретной задачей, прежде всего условиями подготовки и поддержания чистоты (или сохранности)

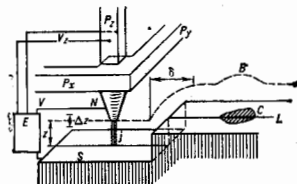


Рис. 1. Схема устройства туннельного микроскопа: V_2 — напряжение обратной связи, регулирующее величину z ; дунатри — туннельная острья, записываемая регистрирующей системой при движении острья над линией L ; B — сланирующая ванна; C — ванна; L — ванна; S — поверхность образца; Δz — модуляция z с целью определения работы выхода.

образца. Малая величина j и низкая энергия туннелирующих электронов исключают опасность повреждения образца током. Длительность записи одного кадра от $\sim 0,03$ с до 30 мин.

Схема устройства С. т. м. приведена на рис. 1. Пьезоэлектрич. пластины P_x, P_y, P_z свободными концами (вне рис. 1) закреплены на станине прибора и при приложении к ним электрич. напряжения двигают острья вдоль соответствующей координаты за счёт собств. деформации (пьезодвигатели). Устройства сближения образца и острья до малого расстояния, перекрываемого пьезодвигателем, осуществлены в разл. вариантах [2]. Блок-схема туннельного микроскопа приведена на рис. 2.

Атомная структура поверхности свежего скола монокристалла графита (долго остающегося чистым на воздухе) часто служит в качестве тест-объекта (рис. 3). Это фотография экрана телевиз. трубки, представляющая собой результат сканирования образца, при к-ром

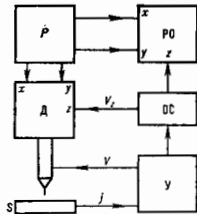


Рис. 2. Блок-схема туннельного микроскопа: У — усилитель туннельного тока; ОС — схема обратной связи; Д — пьезодвигатель острья; РО — устройство регистрации и обработки данных.

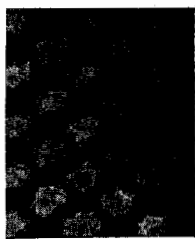


Рис. 3. Атомная структура поверхности ориентированного пироэлектрического монокристалла графита.

сигнал обратной связи V_2 модулирует яркость пятна, перемещающегося по кадру. Светлые пятна — атомы C , выступающие над ср. плоскостью поверхности, тёмные места — углубления между ними.

Одно из первых исследований — изучение реконструктур. структуры поверхности (111) монокристалла Si ; на рис. 4 границы элементарной ячейки (7×7) показаны ромбом, одна сторона к-рого лежит на ступени

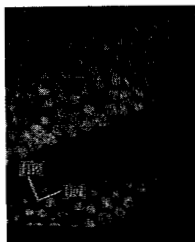


Рис. 4. Атомная структура реконструированной поверхности (111) монокристалла Si .

высотой в один слой атомов [3, 4]. При меньшей разрешающей способности ($\sim 10 \text{ \AA}$) можно изучать состояние поверхности образца на участках большего размера; на рис. 5 показан записанный на двухкоординатном самописце профиль обработанной поверхности (100) кристалла Si (применённого в МДП-структуре для исследования квантового Холла эффекта [5]).

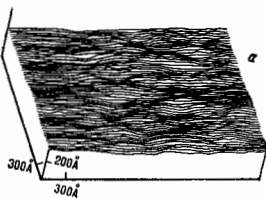


Рис. 5. Поверхность (100) монокристалла Si , обработанная по высшему классу точности.

Успех С. т. м. вызвал появление аналогичных методов исследования поверхностей посредством электрич., световых и др. датчиков. Среди них наиб. интересен сканирующий атомно-силовой микроскоп, основанный

на измерении сил, действующих на микроосцил. алмазное острие, находящиеся на расстоянии $\sim 3-110 \text{ \AA}$ от поверхности образца (к-рый может быть диэлектриком); острие укреплается на чувствит. пружине, деформации к-рой измеряются при помощи С. т. м. [2].

Наиб. важные области применения С. т. м.: исследование атомного строения поверхностей, металлических, сверхпроводящих и полупроводниковых структур, явлений адсорбции и поверхностных хим. процессов, структуры молекул и биол. объектов, технол. исследования в области микро- и субмикроволновой электроники, пленочных покрытий и обработки поверхностей; применение С. т. м. как инструмента обработки поверхностей в субмикроскопии, масштабе в т. д.

Лит.: 1) Виллинг Г., Роберт Н. Scanning tunneling microscopy. «Heiv. Phys. Acta» 1982, т. 55, № 6, с. 728; 2) Эдельман В. С., Сканирующая туннельная микроскопия, «ПТЭ», 1989, № 5, с. 25; ето же, Развитие сканирующей туннельной и силовой микроскопии, «ПТЭ», 1991, № 1, с. 24; 3) Хаяи и И. М. С. и др., Сканирующие туннельные микроскопы, «ПТЭ», 1987, № 4, с. 231; 4) Веккер Р. С. и др., Tunneling images of atomic steps on the Si (111) 7×7 surface, «Phys. Rev. Lett.», 1985, т. 55, № 19, p. 2028; 5) Хаяи и И. М. С. и др., Сканирующая туннельная микроскопия границы раздела Si-SiO₂ в МДП-структуре, «Письма в ЖЭТФ», 1982, т. 44, № 4, с. 193.

СКАЧКОБРАЗНЫЕ МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ — класс марковских случайных процессов, у к-рых значения изменяются мгновенно (скачки) в отдельные (случайные) моменты времени. В наиб. простом случае, когда марковский процесс $\{x_t, t \in R^1\}$ может принимать лишь конечное или счетное число значений x_1, \dots, x_n, \dots для любого фиксиров. момента времени t_0 , условная вероятность того, что в момент времени $t_0 + \Delta t$ ($\Delta t > 0$) процесс примет значение x_{i+1} при условии, что его значение в момент времени t_0 совпадает с x ($=x_i \neq x_k$) (вероятность перескока из x_i в x_k), равна:

$$P\{x_{t_0+\Delta t} = y/x_{t_0} = x\} = q(y, x, t_0)\Delta t + o(\Delta t). \quad (1)$$

При этом усл. вероятность того, что значение x в течение промежутка времени Δt не изменится, оказывается равной

$$1 - \sum_y q(y, x, t_0)\Delta t + o(\Delta t). \quad (2)$$

Величины $\{q(x, y, t) \geq 0, x \neq y\}$ наз. инфинитезимальными вероятностями перехода марковского процесса $\{x_t, t \in R^1\}$. По ним полностью восстанавливается переходная функция $P(x, y, t_1, t_2)$ процесса, т. е. условная вероятность принять процессу в момент времени t_2 значение y при условии, что в момент времени t_1 он принял значение x .

В случае, когда множество возможных значений С. т. м. $\{x_t, t \in R^1\}$ оказывается непрерывным, ф-ла (1) выражает плотность $P_{xy}(y/x, t) = x$ условной вероятности «перескочить» от значения x к значению y за время Δt [при этом в ф-ле (2) сумму по y следует заменить интегралом].

Всякая реализация $\{x(t), t \in R^1\}$ С. т. м. представляет собой кусочно-постоянную ф-цию, у к-рой скачки (разрывы) происходят лишь в отд. изолиров. моменты времени и число таких скачков за любой конечный интервал времени конечно.

Лит.: Грехман И. И., Скороход А. В., Введение в теорию случайных процессов, М., 1985. **СКАЧОК КОНДЕНСАЦИИ** — особая форма скачка уплотнения, возникающая в ускоряющемся сверхзвуковом потоке газа (напр., воздуха) в результате конденсации содержащихся в нём паров воды. При увеличении скорости течения газа, темп-ра торможения к-рого постоянна, его статич. темп-ра монотонно убывает в соответствии с ур-нием:

$$T = T_0 / \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2\right),$$

где $k = c_p/c_v$ — отношение теплоемкостей при пост. давлении и объеме, M — Маха число. Для заданной абс. влажности воздуха a [г/м³] относит. влажность r

возрастает по мере понижения темп-ры. В случае достаточно быстрого падения темп-ры ниже критической и при малом кол-ве ядер конденсации возникает сущест. переохлаждение (перемещение) водяных паров. В результате практически мгновенной объёмной конденсации паров воды и соответствующего выделения скрытой теплоты испарения возникает скачок уплотнения, отличающийся от обычных изменением полной энтропии (и, следовательно, темп-ры торможения) газа в направлении нормали к фронту скачка. При $T_0 \approx 300 \text{ К}$ и относит. влажности $r \approx 50\%$ С. к. возникает при числах $M \approx 1.2$ С. к., наблюдающиеся в соплах аэродинамических труб, обычно имеют х-образную форму. Образование С. к. приводит к сущест. неравномерности поля скоростей и непредсказуемому изменению параметров торможения потока в рабочей части, что затрудняет экстрим. исследования; поэтому совр. аэродинамич. трубы оборудуются спец. установками для осушения воздуха.

М. Я. Кювлович.

СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ, см. Уплотнения скачок.

СКВИД [от англ. Superconducting Quantum Interference Device — сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство; сверхпроводящий квантовый интерферометр (магнитомер)] — высокочувствит. устройство для преобразования магн. потока в эл. сигнал пост. или перем. тока, действие к-рого основано на явлении квантования магн. потока в сверхпроводящем кольце с включенными в него контактами Джозефсона (КД; см. Джозефсона эффект). В результате интерференции сверхпроводящих токов, при изменении магн. потока Φ через кольцо С. выходящий сигнал осциллирует с периодом Φ_0 , равным кванту магн. потока $\Phi_0 = h/2e = 2,068 \cdot 10^{-15} \text{ Вб}$, что связано с фазовой когерентностью сверхпроводящих электронов на макроскопич. расстояниях. Скачок фазы волновой ф-ции сверхпроводящих электронов на КД Φ определяется полным магн. потоком через кольцо ($\Phi = 2\pi\Phi_0/\Phi_0$), а сверхпроводящий ток через КД равен $I_C \sin \varphi = -I_C \sin 2\pi\Phi/\Phi_0$, где I_C — критич. ток КД. При токе $I > I_C$ на КД появляется напряжение $V = \Phi_0(d\varphi/dt)$.

По числу КД в кольце С. и по способу формирования выходного сигнала различают двухконтактные С. пост. тока (ПТ-С.) и одноконтактные С. с ВЧ-начальной (ВЧ-С.). В ПТ-С. через КД пропускается пост. ток, большой критич. значения I_C , и измеряется пост. напряжение на контакте $V(\Phi_x)$, где Φ_x — измеряемый внеш. магн. поток. В ВЧ-С. высокочастотный ток $I_{\text{вч}}$ в кольце С. возбуждается резонансным контуром, причём отклик С. $V_{\text{вч}}(\Phi_x)$ снимается с этого же контура.

Первым ПТ-С. можно считать устройство, в к-ром Ж. Мерсеро [1] с сотрудниками впервые в 1964 наблюдали квантовое интерференционное сверхпроводящих токов [1]. В 1967 Дж. Циммерман [2] и А. Сильвер [2], изучая на перем. токе интерференц. эффекты в сверхпроводящем кольце с точечным КД [2], положили начало ВЧ-С.

Блок-схема ПТ-С. приведена на рис. 1. Если через симметричную конструкцию ПТ-С. (токи через КД равны) пропустить через кольцо С. пост. ток $I_0 > 2I_C$, то на параллельно включенных КД возникает пост. напряжение V , осциллирующее при изменении измеряемого внеш. магн. потока Φ_x через кольцо С., при этом макс. значения $V(\Phi_x)$ достигаются при $\Phi_x = \Phi_0(n + 1/2)$, а минимальные — при $\Phi_x = n\Phi_0$, n — целое число.

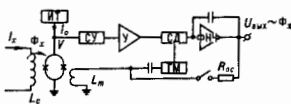


Рис. 1. Схема ПТ-сквида: ИТ — источник постоянного тока; ГМ — согласующее устройство; ГМ — генератор модуляции; У — усилитель; КД — синхронный детектор; ФНЧ — фильтр низких частот.

Макс. размах осцилляций $V(\Phi)$ наблюдается при оптим. значении параметра $Ll_c/\Phi_0 = 1$, где L — индуктивность кольца. Коэф. преобразования для оптимизированных ПТ-С. равен

$$dV/d\Phi_x \approx R/2L,$$

где R — сопротивление шунтированных КД. Шунтирование туннельных КД применяется для создания безгистерезисной вольтамперной характеристики контакта. Современные токоплазменные планарные ПТ-С., изготовленные методами фото- и электронной литографии, имеют коэф. преобразования до 1 мВ/Ф₀.

Усиление и регистрация сигнала С. производится электронными устройствами, находящимися при комнатной темп-ре. Для ослабления влияния НЧ-шумов вида $1/f$ (см. *Флуктуации электрических величин*) используется модуляция. метод обработки сигнала С.: в отн. катушку модуляции (L_m на рис. 1) вводится перем. ток частотой 100—200 кГц, создающий через кольцо С. поток с амплитудой $\sim \Phi_0/4$. Перем. напряжение на С. усиливается, синхронно детектируется и фильтруется. Согласование низкого импеданса С. с высоким импедансом усилителя осуществляется согласующим устройством типа последоват. контура или резонансного трансформатора. Для измерений в большом диапазоне $\Delta \Phi_x > \Phi_0$ используется глубокая отрицат. обратная связь по магн. потоку. Напряжение через сопротивление обратной связи R_{oc} подается в катушку модуляции. В результате измеримый поток компенсируется, а напряжение на резисторе R_{oc} служит выходным сигналом прибора, линейно связанным с измеримым потоком в диапазоне ± 100 —1000 Ф₀.

Блок-схема типичного ВЧ-С., работающего на фиксиров. частоте радиочастотного диапазона 10—400 МГц, приведена на рис. 2. С кольцом С. связана катушка резонансного колебат. контура $L_n C_n$, возбуждаемого генератором тока ВЧ. Резонансный контур согласует низкий импеданс С. с высоким входным сопротивлением усилителя ВЧ. В зависимости от параметра

где ω — частота накачки, k — коэф. связи контура со С. (оптимален k , для k -рого $k^2 Q \approx 1$). Для ВЧ-С. типичны значения коэф. преобразования 20—50 мВ/Ф₀.

Для увеличения отношения сигнал/шум и линеаризации коэф. передачи прибора в схемах ВЧ-С. также применяется доплит. НЧ-модуляция на частотах 10—50 кГц и отрицательная обратная связь по магн. потоку.

Обычно измеремый магн. поток через кольцо С. создается током I_x во входной или сигнальной катушке с индуктивностью $L_c \approx 1$ —10 мкГн ($\Phi_x = MI_x$, где $M = k_c(L_c L_n)^{1/2}$ — взаимная индуктивность сигнальной катушки и кольца С., а k_c — коэф. связи).

Предельная чувствительность С. разл. типа характеризуется т. н. энергетич. чувствительностью:

$$e = (L_c I_n^2) / 2 = \Phi_n^2 / 2Lk_c^2 \text{ (Дж/Гц)},$$

выраженной через спектральную плотность мощности эквивалентного шумового потока Φ_n^2 или шумового тока I_n^2 . Эта величина имеет размерность действия, поэтому иногда ее выражают в единицах $\hbar = 1,05 \cdot 10^{-34}$ Дж/Гц.

Энергетич. чувствительность типичных ПТ-С. $e \sim 10^{11}$ Гц ограничена тепловым шумом резисторов, шунтирующих КД, и равна 10^{-30} — 10^{-31} Дж/Гц. Для ряда ПТ-С., охлаждаемых до $T < 1$ К, достигнуты рекордные значения $e \sim \hbar$ при измерениях малых переменных $\Phi_x \approx 0,01 \Phi_0$ на частотах 100—200 кГц, где не сказывается шум вида $1/f$.

Минимальный детектируемый сигнал ВЧ-С. определяется суммарными шумами усилителя ВЧ, контура и самого С. В оптимизирован. конструкциях при частоте накачки 20—30 МГц шум характеризуется энергетич. чувствительностью $e \sim 5 \cdot 10^{-30}$ Дж/Гц. Поскольку коэф. преобразования ВЧ-С. растёт с частотой, а избыт. шумы падают, выигрыш в чувствительности можно получить, повышая частоту до СВЧ-диапазона (напр., при $f = 10$ ГГц получено $e \sim 10^{-30}$ Дж/Гц). Однако это приводит к существу. усложнению конструкции прибора.

В магн. поток, измеряемый С., легко преобразовать многие магн. и электр. величины: магн. поле в его градиенте, магн. момент, ток, напряжение и др. Однако это преобразование осуществляется с помощью сверхпроводящего трансформатора магн. потока: сигнальная катушка С. образует замкнутый сверхпроводящий контур с приёмной катушкой. Внесредственно воспринимаемое изменение магн. потока. В силу сохранения потока в этой цепи экранирующий ток «переносит» часть измеремого потока в сигнальную катушку, связанную с кольцом С.

Чувствительность сверхпроводящих С.-магнитометров достигает $5 \pm 10 \cdot 10^{-15}$ Тл/Гц^{1/2} и определяется уже магн. шумом в тщательно экранированных помещениях. По чувствительности С.-магнитометры превосходят традиц. магнитометры на 2—3 порядка. С.-магнитометры применяются, напр., для измерения *важнтых* *малей биологических объектов* [8], магнитометрии, исследования в геофизике и геологии [9], измерения магн. восприимчивости веществ и материалов.

Применение С. для измерений электрич. величин позволяет достичь пороговой чувствительности по току 10^{-12} — 10^{-14} А/Гц^{1/2} при нулевом сопротивлении сигнальной катушки. По напряжению чувствительность ограничена тепловым шумом низкоомных (10^{-4} — 10^{-2} Ом) источников сигнала и составляет при низких темп-рах 10^{-12} — 10^{-15} В/Гц^{1/2}. С.-гальванометры и С.-вольтметры служат для измерения проводимости и термоэлектрич. эффектов в нормальных и сверхпроводящих металлах. В метрологии С.-гальванометры служат в качестве нуль-индикаторов в эталонных установках, к-рые позволяют единицу эдм (Вольт) на основе эффекта Джозеф-

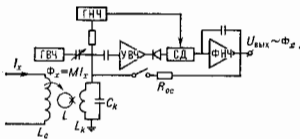


Рис. 2. Схема ВЧ-сквида: ГВЧ — генератор высокой частоты; ГЧЧ — усилитель высокой частоты; ГНЧ — генератор модуляции низкой частоты; СД — синхронный детектор, ФНЧ — фильтр низких частот.

$I = 2\pi Ll_c/\Phi_0$ различают безгистерезисный ($I < 1$) и гистерезисный ($I > 1$) режимы работы ВЧ-С. В первом случае кольцо С. представляет собой параметрич. индуктивность, осциллирующую с изменением внеш. потока Φ_x . Изменение индуктивности регистрируется по сдвигу резонансной частоты контура $L_n C_n$. Безгистерезисный режим работы ВЧ-С. редко используется в практич. устройствах из-за жестких ограничений на параметры С., стабильность амплитуды и частоты сигнала ВЧ-накачки.

Если $I > 1$, воздействие магн. потока накачки с амплитудой, достаточной для возбуждения в кольце КД тока $I_{кч} > I_c$, приводит к характерным гистерезисным потерям энергии в колебат. контуре, урывает к-рых осциллирует в зависимости от внеш. потока Φ_x с периодом Φ_0 . Соответствующее изменение добротности контура Q регистрируется по изменению напряжения $V_{нч}(\Phi_x)$ на нём. Коэф. преобразования магн. потока в напряжение для ВЧ-С. в гистерезисном режиме равен:

$$dV_{нч}/d\Phi_x = (\omega/k)(L_n/L)^{1/2},$$

сона и единицу сопротивления (Ом) на основе квантового Холла эффекта (см. Квантовая метрология); шумовой термометр на основе С. используется при установлении шкалы сверхнизких темп-р [5].

Осп. недостатком С., препятствующим их более широкому распространению, являются необходимость охлаждения до уровня гелиевых или водородных темп-р при применении традиц. сверхпроводящих материалов. Открытие в 1986—87 оксидных высокотемпературных сверхпроводников с $T_c \approx 100$ К открывает перспективы создания С. при авт. темп-рах [10].

Лит.: 1) Jaklevic R. C. и др., Quantum interference from a static vector potential in a field-free region, *Phys. Rev. Lett.*, 1964, v. 12, № 11, p. 274; 2) Silver A. H., Zimerman J. E., Quantum states and transitions in weakly connected superconducting rings, *Phys. Rev.*, 1967, v. 157, p. 317; 3) Соловьев Л., Гигантский эффект в сверхпроводниках и его применение, пер. с англ., М., 1974; 4) Дихарев К. К., Ульрих В. Т., Системы с диозофосфорными контактами, М., 1978; 5) Слабая сверхпроводимость. Квантовые интерферометры и их применения, пер. с англ., М., 1980; 6) Варазе А., Патерно Д., Эффект Дюозофосфора: физика и применения, пер. с англ., М., 1984; 7) Дихарев К. К., Введение в динамику диозофосфорных переходов, М., 1985; 8) Введение в физику В. Д. С. Жегалин В. И., Сверхчувствительная магнетометрия и биоматематика, М., 1986; 9) О де Ганн Л., Некоторые нестандартные применения сверхпроводящих квантовых интерферометров — сквидов (обзор), «Физика низких температур», 1988, т. 14, с. 5; 10) Тейсес С. Д., Superconducting magnetometers, *Cryogenics*, 1989, v. 29, p. 1135.

И. Я. Краснопольн.

СКЕЙЛИНГ — то же, что масштабная инвариантность.

СКИН-ЭФФЕКТ — затухание эл.-магн. волн по мере их проникновения в проводящую среду. Переменное во времени электрич. поле E и связанное с ним магн. поле H не проникают в глубь проводника, а сосредоточены в осн. в относительно тонком приповерхностном слое толщиной δ , называемой глубиной скин-слоя. Происхождение С.-э. объясняется тем, что под действием веш. перем. поля в проводнике свободные электроны создают ток, поле к-рых компенсирует веш. поле в объеме проводника. С.-э. проявляется у металлов, в плазме, ионосфере (на коротких волнах), в вырожденных полупроводниках и др. средах с достаточно большой проводимостью.

Глубина скин-слоя существенно зависит от проводимости σ , частоты эл.-магн. поля ω , от состояния поверхности. На малых частотах δ велика, убывает с ростом частоты и для металлов на частотах оптич. диапазона оказывается сравнимой с длиной волны $\lambda \sim 10^3$ см. Столь малым проникновением эл.-магн. поля и почти полным его отражением объясняется металлич. блеск хороших проводников. На ещё больших частотах, превышающих плазменную частоту, в проводниках оказывается возможным распространение эл.-магн. волн. Их затухание определяется как внутризонными, так и межзонными электронными переходами (см. Зонная теория).

Теоретич. описание С.-э. сводится к решению кинетич. ур-ния для носителей заряда с целью определения связи тока с полем и последующему решению Максвелла уравнений. Наб. процесс описывается т. е. нормальным С.-э., к-рый имеет место, когда δ велика по сравнению с эфф. длиной свободного пробега l электронов. Величина l определяется расстоянием, проходимым электроном за время τ между 2 актами рассеяния (τ — время релаксации) либо за период поля $1/\omega$ в зависимости от того, какая из этих длин меньше. В общем случае $l = v/(\tau^{-1} - \omega)$, где v — скорость электрона.

При нормальном С.-э. распределение поля в проводнике зависит лишь от дифференц. проводимости σ , отличия к-рой от проводимости на пост. токе σ_0 учитываются (для изотропной среды) соотношением $\sigma = \sigma_0/(1 - i\omega\tau)$; оно зависит также от формы поверхности образца. Проводимость связана с диэлектрич. проницаемостью ϵ среды соотношением $\epsilon = \epsilon_0 + 4\pi i\sigma/\omega$, где ϵ_0 — вклад в диэлектрич. проницаемость локализо-

ванных электронных состояний (диэлектрич. проницаемость ионной решетки).

Для плоской поверхности образца (плоскость поля) и нормального падения волны (э. распределение z в проводнике имеет вид

$$E(z) = E(0) \exp(-z/\delta) \cos\left(\frac{\omega}{c}nz - i\omega t\right),$$

где $E(0)$ — амплитуда поля на поверхности, $\delta = c/\omega\sigma$, коэф. преломления n и затухания k связаны соотношением $\sqrt{\epsilon} = n + ik$, где диэлектрич. проницаемость $\epsilon = \epsilon_0 + 4\pi i\sigma/\omega$ (ϵ_0 — диэлектрич. проницаемость решетки) (см. Высококачественная проводимость).

Для цилиндрич. провода радиусом r_0 распределение поля выражается через функцию Бесселя:

$$E(r) = E(r_0) \operatorname{Re}\left\{\exp(-i\omega t) J_0(kr)/J_0(kr_0)\right\},$$

где $E(r_0)$ — поле на поверхности, $k = (n + ik)\omega/c$. С.-э. существенно сказывается на зависимости сопротивления провода от его радиуса. В то время как на пост. токе сопротивление провода R прямо пропорционально площади сечения $R = L/\pi r_0^2 \sigma_0$, на переменном токе в предельном случае, когда ток течёт в очень тонком приповерхностном слое ($\delta \ll r_0$), сопротивление обратно пропорционально длине окружности поперечного сечения

$$R = L/2\pi r_0 \delta \sigma.$$

В пределе НЧ, когда можно не учитывать частотную дисперсию σ , а также пренебречь величиной ϵ_0 , глубина скин-слоя:

$$\delta = c(2\pi\sigma_0\omega)^{-1/2},$$

коэф. преломления:

$$n = (2\pi\sigma_0/\omega)^{1/2}.$$

С повышением частоты в ИК-области для металлов при условии $\omega\tau \gg 1$ ($\tau \gg 1/\omega$) проводимость $\sigma = i\sigma_p/\omega = i\sigma_p^2/4\omega$, где ω_p — плазменная частота электронов. В этом диапазоне $\tau^{-1} \ll \omega \ll \omega_p/\sqrt{\epsilon}$ и глубина скин-слоя $\delta = c/\omega_p$, т. е. не зависит от частоты и выражается через концентрацию электронов и их эфф. массу m , т. к. $\omega_p^2 = 4\pi N e^2/m$. В этом же диапазоне коэф. n мал по сравнению с k и взаимодействие электронов с поверхностью образца существенно влияет как на l , так и на поглощение энергии, пропорциональное мнимой части ϵ . Сталкиваясь с поверхностью, электроны рассеиваются на статич. неоднородностях и тепловых поверхностных колебаниях (см. Поверхность).

Аномальный С.-э. описывает ситуацию при $l > \delta$; он наблюдается в СВЧ-диапазоне в чистых металлах при низких темп-рах. Связь между плотностью тока j и полем E является здесь неколлающей, т. е. значение тока в нек-рой точке проводника определяется полем в окрестности этой точки с размером $\sim l$. Задача о распределении поля сводится к интегро-дифференц. ур-нию, решение к-рого даёт, в частности, асимптотич. закон убывания поля E . Наряду с компонентой, убывающей на расстоянии $\sim \delta$ от поверхности, наблюдается медленное убывание на расстоянии $\sim l$. Выражение для δ в этом случае иное. Напр., для предельно аномального С.-э., т. е. при $\delta \ll l$, глубина скин-слоя

$$\delta = (vc^2/\omega\sigma_0)^{1/2}.$$

При аномальном С.-э. рассеяние электронов на поверхности образца мало сказывается на величине δ . Здесь существенную роль играют электроны с малыми углами скольжения, для к-рых отражение близко к зеркальному. Заметно влияет на аномальный С.-э. пост. магн.

поле H , параллельное поверхности. Электроны, захваченные магн. полем, при зеркальном отражении многократно сталкиваются с поверхностью образца и долгое время движутся в пределах скин-слоя. Это приводит к росту проводимости и уменьшению глубины скин-слоя

$$\delta = c^2 v_{gr} \frac{1}{L} / \omega \left| \frac{\omega}{\omega_p} \right|^{1/2},$$

где $v_{gr} = mc/\hbar N$ — ларморовский радиус; предполагается $v_{gr} > \delta$. Др. электроны, не сталкиваясь с поверхностью, возвращаются в скин-слой после каждого оборота вокруг магн. поля, благодаря чему в металлах наблюдается *циклотронный резонанс*.

Более точный расчет, смысл сл. при нормальном, так и аномальном С.-э. (в отличие от δ) имеет поверхностный импеданс Z . В НЧ-области нормального С.-э.

$$Z = 2\omega/c^2 \sigma_0$$

и уменьшается с темп.-рой T , т. к. растёт δ_0 . Для предельно аномального С.-э. импеданс

$$Z = (\pi/3)^{1/2} \pi \omega B / c^2 \sigma_0^{1/2} (1 - \sqrt{1/3}),$$

где параметр B определяется спектром электронов; в изотропном приближении $B = v^2/\omega_p$.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982, с. 291—99; Лифшиц Е. М., Пятаевский В. И., Физическая кинетика, М., 1978, с. 436—49; Рапопорт Л. А., Травяков Р. Ф., *Adv. in Phys.*, 1983, в. 32, № 5, p. 753; Абрамов А. А., Основы теории металлов, М., 1987, с. 105—117. Л. А. Фольковский.

Скин-эффект нелинейный. При достаточно высоких значениях напряжённости перем. эл.-магн. поля, когда параметры среды, напр. проводимость σ , начинают зависеть от поля, С.-э. становится нелинейным, т. е. толщина скин-слоя δ также начинает зависеть от интенсивности эл.-магн. поля. Наиб. легко нелинейный С.-э. реализуется в плазме. Пороговые значения амплитуды электрич. и магн. полей, при к-рых происходит переход С.-э. в нелинейный, зависят от параметров среды и частот.

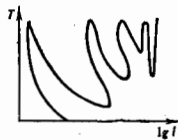
В области НЧ определяющее влияние на проникновение поля оказывает дифференц. проводимость среды. Зависимость её от электрич. поля (т. е. электрической величины) обуславливается разогревом носителей, аномальным сопротивлением, разлом среды и т. д. Пороговые амплитуды, при к-рых возникает нелинейность дифференц. электрич. проводимости, могут различаться весьма сильно для разных механизмов нелинейности. Вследствие этого затухание эл.-магн. поля может быть не экспоненциальным, а, напр., степенным или к.-л. другим в зависимости от вида $\langle E \rangle$, т. е. меняется структура скин-слоя. Но характерный масштаб затухания по порядку величины остаётся равным $\delta \propto \sqrt{2\pi\omega_0 \langle E \rangle^{1/2}}$.

Значительно большее влияние в этой области частот оказывают магнитные нелинейности, к-рые, напр. могут менять С.-э. не только количественно, но и качественно. Их действие проявляется при условии $\omega_{dr} \geq 1$, где $\omega_{dr} = eH/mc$ — циклотронная частота носителей. В режиме магн. нелинейности С.-э. необходимо учитывать тензорный характер сопротивления среды в магн. поле. Зависимость диагональных компонент сопротивления ρ от H (*магнетосопротивление*) аналогична влиянию электрич. нелинейности. Нondiagonalные компоненты тензора сопротивления (см. *Холла эффект*) наиб. ярко проявляются в вестационарной задаче о проникновении в плазму постоянного магн. поля, включаемого в нек-рый момент времени $t = 0$. Тогда глубина проникновения поля в плазму меняется со временем: $\delta \propto \sqrt{t} \rho(E, H)^{1/2}$. В режиме нелинейного С.-э. в зависимости от напряжённости магн. поля вместо обычного диффузионного закона проникновения магнитного поля, при к-ром $\delta \propto t^{1/2}$ происходит

либо быстрое конвективное проникновение поля в плазму со скоростью порядка токовой скорости носителей (т. е. $\delta \propto t$), либо задержание поля на конечной толщине (т. е. $\delta(t) \rightarrow \text{const}$). Сущест. роль в этих процессах играет неоднородность среды, а именно, если носители при токовом движении попадают в область более высокой своей концентрации, то реализуется конвективное проникновение, в противоположном случае — задержание.

При наложении на плазму переменного магн. поля может возникнуть эффект детоксирования, состоящий в том, что наряду с формированием скин-слоя у границы плазмы в глубь среды уходит нелинейная волна поля нек-рогого фиксиров. направления, зависящего от направления градиента концентрации носителей, а другие направления задерживаются.

В ИК-области, когда $\delta = c/\omega_p$, нелинейные изменения происходят при $H^2/8\pi \geq H_{me}^2$, когда носителей в скин-слое толщиной c/ω_p не хватает для переноса тока даже при их движении со скоростью, близкой c . В результате глубина проникновения поля увеличивается (чтобы возмещ. число носителей) до необходимой для поддержания тока: $\delta = H/4\pi N_e$. В области высоких частот $\omega \lesssim \omega_p$ толщина скин-слоя в плазме может как уменьшаться, так и возрастать в зависимости от знака нелинейного вклада в диэлектрич. проницаемость. В отличие от линейного режима, в случае нелинейного С.-э. при медленном увеличении напряжённости поля оно, начиная с нек-рой пороговой амплитуды, проникает в глубь плазмы на расстояние, определяемое диссипативным затуханием. (Это происходит при положительном вкладе.) В случае достаточно слабой диссипации нелинейное проникновение поля и плазму может носить характер гистерезиса, т. е. зависит от предстории процесса. Напр., для плазменного слоя конечной толщины эффективность T проникновения эл.-магн. волны через слой, измеряемая отношением потоков энергии после слоя и перед ним, является неоднозначной ф-цией интенсивности падающей волны I (как схематически показано на рис.).



Зависимость эффективности проникновения T электромагнитной волны через слой от её интенсивности I .

Наличие развитой турбулентности плазмы также приводит к изменению как динамики С.-э., так и глубины скин-слоя, к-рая будет зависеть от интенсивности турбулентности, поскольку в нелинейном С.-э. взаимодействие носителей с турбулентными пульсациями существенно меняет отклик плазмы на приложенное к ней поле. Это связано, в частности, с изменением эфф. частот соударений носителей ω_{dr} при их сильном рассеянии на турбулентных пульсациях. Напр., в изотропной бестолкнутой плазме с развитой ионно-звуковой турбулентностью, имеющей характерные длины волн $\lambda_t \sim v_{te}/\omega_{pe}$, скинвая глубина $\delta = (c/\omega_{pe})(\omega_p/12n_e T_e)^{1/2}$, где ω_p — плотность энергии ионно-звуковых колебаний; n_e , T_e — концентрация и темп.-ра электронов.

Глубина скин-слоя δ может резко возрастать, если в плазме возможны процессы трансформации приложенного к плазме перем. эл.-магн. поля в слабозатухающие собств. колебания, напр. в ленгмюровские волны, к-рые переносят поле на расстояния порядка обратной величины декремента затухания этих волн (см. *Трансформация волн в плазме*).

Лит.: Пятаевский В. И., Теория турбулентной плазмы, М., 1971; Владимирова В. В., Волков А. Ф., Мелихов Е. З., Плазма полупроводников, М., 1979; Кондра-

текио А. Н., Проникновение поля в плазму, М., 1979; Книг-сеп А. С., Чукбар К. В., Дьяков В. В., Электронная магнитная гидродинамика, в сб.: Вопросы теории плазмы, т. 16, М., 1987, с. 209; Кочетов А. В., Миrows В. А., Динамика нелинейного протекания плотной плазмы, «Физика плазмы», 1990, т. 16, № 3, с. 248.

Н. С. Брехин, К. В. Чукбар.

СКИРМА МОДЕЛЬ — теоретич. модель для описания в рамках эффективной нелинейной теории мезонных полей стабильных протяженных частиц (барнионов). Предложена в 1961 Т. Х. Р. Скимром [1, 2] и относится к нелинейной *сигма-модели*. С. м. обладает сохраняющимся независимо от ур-ний динамики модели *топологическим зарядом*, к-рый можно интерпретировать как барнионное число, и т. н. солитонным механизмом генерации спектра масс (см. *Солитон*). Согласно гипотезе Скимры, барнион трактуется как киральный солитон, возникающий в результате коллективного возбуждения пионных полей. Появление таких возбуждений тесно связано с явлением спонтанного нарушения *киральной симметрии* (см. *Спонтанное нарушение симметрии*), подобно тому как включение магн. поля, нарушающего изотропию пространства, приводит к спонтанной намагниченности ферромагнетика.

Осп. объектом С. м. является поле $g(x)$, принимающее значения в многообразии групп $SU(2)$ и параметризуемое изовекторным полем $\Psi^a(x)$ (триплетом пионных полей):

$$g(x) = \exp\{i\tau^a n^a \theta(x)\}; \quad n^a = \Psi^a / |\Psi|; \quad \sin \theta = \pm |\Psi|; \quad a = 1, 2, 3, \quad (1)$$

где τ^a — Паули матрицы, действующие в пространстве изотонч. спина; $\theta(x)$ — т. н. киральный угол; $x = (x^0 = t, \mathbf{x})$. Модели, для к-рых поля принимают значения в век-ром многообразии компактной группы или однородном пространстве, принято называть киральными. Поля (1), удовлетворяющие естеств. граничным условиям на пространственной бесконечности

$$g(x) \rightarrow I (\Psi^a(x) \rightarrow 0) \quad \text{при} \quad |\mathbf{x}| \rightarrow \infty \quad (2)$$

(I — единичная 2×2 матрица) в фиксиров. момент времени t , можно рассматривать как отображения g в трехмерного пространства R_3 или трехмерной сферы S_3 [т. к. в силу (2), R_3 компактифицируется в сферу S_3] в группу $SU(2)$ [$g: R_3 \rightarrow SU(2)$ или $S_3 \rightarrow SU(2)$]. По отношению к непрерывной деформации (гомотопии), частным случаем к-рой является временная эволюция полевой системы, такие отображения разбиваются на классы эквивалентности, называемые гомотопическими классами. Каждый гомотопич. класс является элементом гомотопич. групп $\pi_n(SU(2))$ и характеризуется значением гомотопич. инварианта — топологич. заряда Q .

Для явного вычисления Q удобно использовать левые киральные токи

$$L_a = g^{-1}(x) \frac{\partial g(x)}{\partial x^a}, \quad \mu = 0, 1, 2, 3, \quad (3)$$

со значениями в Ли алгебре группы $SU(2)$, в терминах к-рых

$$Q = \int d^3x J^0 = - \frac{e^2 \mu^2}{48\pi^2} \int d^3x \text{Sp} [L_a [L_a, L_a]], \quad (4)$$

где J^0 — временная компонента топологич. тока J^μ , закон сохранения к-рого $\partial J^\mu / \partial x^\mu = 0$ выполняется тождественно без привлечения ур-ний динамики модели, $[L_a, L_b] = \epsilon_{abc} L_c$ — коммутатор левых киральных токов, $e^2 \mu^2$ — *Левы-Числовы символы* (по повторяющемуся индексу предполагается суммирование). Наличие изоморфизма $\pi_3(SU(2)) \approx Z$, где Z — группа целых чисел, означает, что Q принимает на каждом делительном значении и имеет смысл степени отображения, т. е. показывает, сколько раз $SU(2)$ -многообразие об-

ходится полем $g(x)$ при однократном пробытании точки x по физ. пространству R_3 .

Лагранжиан С. м. записывается через токи L_a в виде

$$\mathcal{L} = \int d^3x \left\{ - \frac{1}{4\lambda^2} \text{Sp} L_a^2 + \frac{e}{10} \text{Sp} [L_a, L_a] \right\}, \quad (5)$$

где λ и e — нек-рые параметры. Первый член в выражении (5) — т. н. киральный лагранжиан Вайнберга, к-рый в «среднем» приближении воспроизводит результаты *алгебры токов* для низкоэнергетич. динамики пионов. Добавление члена 4-го порядка по L_a (скирмского члена) обеспечивает существование стабильных солитонных решений вследствие наличия для функционала энергии $\mathcal{E}[\Psi]$ С. м. оценки снизу через топологич. заряд (4):

$$\mathcal{E} > 6\sqrt{2} \pi^2 \frac{e}{\lambda} |Q|. \quad (6)$$

Ур-ния движения для С. м.

$$\partial_\mu (L^\mu - \frac{e^2 \mu^2}{2} [L_a, L^a, L^a]) = 0 \quad (7)$$

имеют вид локального закона сохранения величины типа изоспина. Отыскание структуры решений ур-ния (7) основывается на свойствах симметрии лагранжиана (5) и соответствующего функционала энергии $\mathcal{E}[\Psi]$. Выражение (5) инвариантно относительно преобразования из киральной группы $SU(2)_L \times SU(2)_R$, к-рые следующим образом действуют на поля $g(x)$: $g \rightarrow g' = u v g v^{-1}$, где u и v — произвольные матрицы соответственно из $SU(2)_L$ и $SU(2)_R$ (индексы L и R соответствуют подгруппы соответственно левых и правых вращений). Но вакуумное состояние $g_0 = I$ (т. е. $\theta = 0$) такой инвариантностью не обладает до тех пор, пока $u \neq v$. Это означает, что С. м. принадлежит к классу нелинейных o -моделей со спонтанно нарушенной киральной симметрией. Из-за неинвариантности вакуума внутр. симметрия конфигурац. пространства С. м. $SU(2)_L \times SU(2)_R$ нарушается до подгруппы $\text{diag}[SU(2)_L \times SU(2)_R] \approx SU(2)_I \approx SO(3)_I \times Z_2$, т. е. до группы изотонч. вращений. Поскольку нетривиальных $SO(3)_I$ -инвариантных полей не существует, то изотонч. вращения объединяются с пространственными и в качестве группы инвариантности функционала $\mathcal{E}[\Psi]$ рассматривается группа

$$G_I = \text{diag}[SO(3)_I \times SO(3)_S], \quad (8)$$

где $SO(3)_S$ — группа пространственных вращений. Класс инвариантных относительно (8) сферически-симметричных полей задается ф-лой

$$g(r) = \exp\{i\tau^a x^a \theta(r)/r\}; \quad r = |\mathbf{x}|, \quad (9)$$

предложенной Скимром [1]. В честь автора модели решение (9) с топологич. зарядом $Q = 1$ получило в литературе назв. *скирмион*. Энергия (масса) скирмиона записывается в виде

$$\mathcal{E} = \frac{4\pi e}{\lambda} \int_0^\infty dx \left\{ \left(\frac{d\theta}{dx} \right)^2 \left(\frac{x^2}{2} + 2\sin^2 \theta \right) + \sin^2 \theta + \frac{\sin^4 \theta}{x^2} \right\}, \quad (10)$$

где положено $r = e\lambda x$, ф-ция $\theta(x)$ подчинена граничным условиям: $\theta(0) = \pi$; $\theta(\infty) = 0$. В силу неравенства (6) скирмион устойчив и, более того, реализует абс. минимум энергии для полей с $|Q| = 1$, т. е. является осн. состоянием с наим. массой среди изовекторных полей с нетривиальным топологич. зарядом [3].

Все перечисленные выше свойства и дают основания для рассмотрения скирмиона как простейшей модели барниона. Для полей с топологич. зарядами $|Q| \geq 2$ группой инвариантности функционала энергии является

$$G_2 = \text{diag}[SO(2)_I \times SO(2)_S], \quad (11)$$

и абс. минимум $\sigma[\varphi]$ реализуется в более широком классе аксиально-симметричных полей (см., напр., [3]). В случае $Q = 2$ такие решения интерпретируются как дубляжи.

Дальнейшее развитие идея описания барьона как кирального солитона получила в работах Э. Виттена [4, 5], к-рый выявил связь между величайшим σ -моделью со спонтанно нарушенной киральной симметрией и низкоэнергетич. приближением *квантовой хромодинамики* (КХД). Исходя из учёта симметричных свойств фундамент. лагранжиана КХД, Виттен рассмотрел $SU(3)$ -обобщение С. м. Это позволило ему построить явный вид двузначных функционалов, описывающих квантовомеханич. состояния в модели, и на этой основе конструктивно решить вопрос о спине скирмиона, т. е. показать, в каком смысле скирмион можно трактовать как фермион. Кроме того, в рамках квазиклассич. подхода удалось качественно правильно воспроизвести спектроскопию адронов и рассчитать их статич. свойства (магн. моменты, зарядовые радиусы, константы взаимодействий и т. д.). Разумные ответы получаются и при использовании С. м. для вычисления разл. характеристик низкоэнергетич. процессов с участием барьонов [6].

Т. о., в целом С. м. качественно правильно передаёт гл. черты будущей мезонной теории, к-рая должна получаться из первоосов КХД, и в силу своей отпосит. простоты может служить основой для апробации методов, предлагаемых для проведения расчётов в низкоэнергетич. области КХД.

Лит.: 1) Skyrme T. H. R., A non-linear field theory, Proc. Roy. Soc., 1961, v. A260, p. 127; 2) Skyrme T. H. R., A unified field theory of mesons and baryons, Nucl. Phys., 1962, v. 31, p. 556; 3) Маханьков В. Г., Рыбанов Ю. П., Санюк В. И., Модель Скирмы и ее взаимодействия, УФН, 1992, т. 162, с. 1; 4) Witten E., Global aspects of current algebra, Nucl. Phys., 1983, v. B223, p. 422; 5) Witten E., Current algebra, baryons and quark confinement, там же, p. 433; 6) Zahed I., Brown G. E., The Skyrme model, Phys. Repts., 1988, v. 142, p. 1.

В. И. Соколов

СКОЛЬЗЯЩИЙ РАЗРЯД — разность между импульсным искровым разрядом по поверхности диэлектрика. Картины распределения искровых каналов на поверхности диэлектрика при С. р. впервые наблюдались в 1777 Г. К. Лихтенбергом (G. Ch. Lichtenberg) и наз. *Лихтенберги фигуры*. В сильных разрядах высокие давления и темп-ры деформируют поверхность диэлектрика, запечатывая фигуры Лихтенберга; в слабых разрядах их можно сделать видимыми, посылая поверхность диэлектрика спец. порошком или проявляя подложку под слой диэлектрика фотопластику. Впервые в фотографии С. р. был использован в 1887 А. Теллером (A. Toepfer).

Типичная конфигурация электродов, между к-рыми происходит С. р., приведена на рис. 1: один из электродов (1) представляет собой тонкую проволочку, другой (3) — плоскую поверхность, отделённую от первого слоем диэлектрика (2), по к-рому стелется разряд.

Рис. 1. Скользящий по поверхности диэлектрика разряд: 1 — инцидирующий электрод; 2 — диэлектрическая подложка; 3 — металлическая подложка — второй электрод.

Такая искровая конфигурация создаёт резко неравномерное электрич. поле E с преобладанием нормальной составляющей к поверхности диэлектрика. Поэтому в С. р. могут быть достигнуты высокие значения E при умеренных амплитудах питающих высоковольтных импульсов.

При воздействии на электроды С. р. высоковольтного импульса напряжения с амплитудой 10^4 – 10^6 В и скоростью нарастания $\sim 10^{12}$ В/с в разрядном промежутке складываются условия, характерные для наносекундного проба электрического. Напряжённость

электрич. поля в промежутке может усиливаться до 10^8 раз на микровыверстах поверхности диэлектрика и электродов. При этом время развития разряда становится соизмеримым со временем протекания элементарных процессов в плазме, что приводит к отклонению от лавинового (тауисседовского) и стримерного механизмов (см. *Пробой газа*), и даже при протекании больших токов ($\sim 10^6$ А) разряд остаётся диффузным, кавад дугового разряда не образуется.

В таких жестких режимах ток лидерной (незавершённой) стадии может превышать ток последующего завершённого С. р., замыкающего разрядный промежуток, а излучение разряда на этой стадии содержит интенсивную УФ-компоненту (вплоть до мягкого рентгена). Это излучение создаёт свободные фотоэлектроны на расстояниях, значительно превышающих критич. размеры первичных лавин. При импульсном напряжении 50–200 кВ вдоль поверхности диэлектрика легко возникают плазменные поверхности протяжённостью до 200 см, яркостная темп-ра к-рых может достигать $6 \cdot 10^4$ К. Спецфика С. р. определяется активным взаимодействием плазмы разряда с поверхностью диэлектрика, что отражается на спектральных характеристиках излучения плазмы. Канал С. р. ограничен в пространстве диэлектрич. подложкой, поэтому площадь его сечения меньше, а погонное электрич. сопротивление соответственно больше, чем у свободного искрового разряда. Малая индуктивность и относительно большое сопротивление завершения С. р. обеспечивают высокую мощность энерговыделения в канале разряда, что приводит к образованию плотной высокотемпературной плазмы с большой площадью излучающей поверхности ($\approx M^2$).

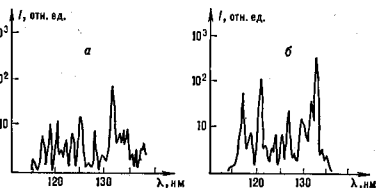


Рис. 2. Спектр излучения искровых разрядов в воздухе при атмосферном давлении: а — искровой разряд между вольфрамовыми электродами; б — завершённый скользящий разряд по поверхности лавсановой плёнки.

Поступление паров диэлектрика в плазму С. р. изменяет спектр его излучения, что важно при использовании С. р. как открытого источника УФ-излучения. На рис. 2 представлены спектры обычного искрового и скользящего по поверхности диэлектрика разрядов при одинаковом уд. энерговыделении. Видно, что в области вакуумного ультрафиолета интенсивность спектральных линий в случае С. р. на порядок выше. Т. к. спектр излучения С. р. имеет ярко выраженную дискретность, то возможно повышать интенсивность излучения в нужной спектральной области подбором соответствующего материала диэлектрич. подложки.

С. р. широко применяется при решении ряда научно-прикладных задач, в частности при создании низковольтных сверхточечных коммутаторов, источников предионизации в импульсных газовых лазерах, плазменных электродов для организации однорядного сильного токового разряда при повышенных давлениях (см. *Электроды плазменные*). Плазма С. р. используется в качестве активной среды лазера на самоограниченных переходах (лазеры на N_2 , Ar, Ne и др.).

Лит.: Фольгарт К., Искровые источники света и высокочастотная кинематография, в кн.: Физика быстропотекающих процессов, пер. с нем., англ., т. 1, М., 1971; Дэй у П. Н., Челнок о в Л. Л., Рыбанов В. М. Д., Характеристики

скользящего разряда по поверхности твердых диэлектриков применительно к высоковольтным коммутаторам. «Электронная техника», сер. 4. Электронные и газоразрядные приборы, 1975, № 6, с. 9; Андреев С. И., Зобов Е. А., Сидоров А. Н., Метод управления разрядом и формированием систем параллельных каналов скользящих искр в воздухе при атмосферном давлении. «Ж. ЦИТО», 1976, № 3, с. 12; Зарослов Д. Ю., Кузьмин Г. П., Тарасенко В. Ф., Скользящий разряд с CO₂ и эксимерных лазерах, «Радиотехника и электроника», 1984, т. 29, в. 7, с. 1217; Брыляков П. И. и др. Алгоритм расчета осевого скользящего по поверхности диэлектрика разряда. «Квантовая электроника», 1988, т. 15, № 10, с. 1971. Г. П. Кузьмин.

СКОПЛЕНИЯ ГАЛАКТИК — гигантские плотные группировки галактик, содержащие горячий ионизованный газ и невидимое вещество. Обычно С. г., в отличие от групп, цепочек и др. систем галактик, называют комплексами, имеющие размеры прибл. до 1,5–3 Мпк и включающие от неск. сотен до десятков тысяч галактик высокой и средней светимости. Форма С. г. близка к эллиптической. С. г. делятся по богатству (кол-во галактик) на 6 классов — от 0 до 5. Ближайшее к Галактике С. г. в созвездии Девы (класс богатства 0) содержит ок. 200 галактик, в т. ч. 7 гигантских эллиптических и 10 гигантских спиральных галактик. Ближайшее богатое С. г. в созвездии Волосы Вероники (класс 2 или 3) содержит ок. 10⁴ галактик высокой и средней светимости, преим. эллиптических и линзовидных, и очень мало спиральных галактик. Концентрация галактик в центрах богатых (класса 2 и выше) С. г. превышает 10⁹ Мпк⁻³. Известно ок. 3000 богатых С. г. В скоплениях входит часть всех галактик. Галактики скопления обеспечиваются лишь ок. 5% светимости всех галактик.

При сравнительно небольших размерах С. г. в них наблюдаются очень большие среднеквадратичные скорости галактик (v) — до 1–2·10³ км/с. Согласно *виртала теореме* это означает, что С. г. обладают очень большой массой (виртальной массой) M_v , определяемой соотношением

$$M_v = 2\alpha R v^2 G^{-1} \approx 0,5\alpha 10^{14} M_\odot v^2 R,$$

где R — радиус скопления (Мпк); M_\odot — масса Солнца; G — гравитационная постоянная; α — безразмерный численный коэф. порядка 1, зависящий от распределения плотности С. г. (в тыс. км/с). С др. стороны, зная светимость С. г. и зависимость масса — светимость (см. *Масса — светимость зависимость*) для галактик, входящих в скопление, можно оценить массу светящегося вещества скопления, M_L . Такие оценки выполнены для центр. частей неск. десятков С. г. Найдено, что $M_L \sim \sim 0,1 M_v$. Значит, расхождение оценок M_L и M_v , впервые отмеченное Ф. Цвикки (F. Zwicky) в 1930-х гг., является одним из самых серьезных свидетельств данных наблюдений в пользу существования невидимого тяготеющего вещества (*скрытой массы*), к-рое в масштабах С. г. прибл. в 10 раз превосходит массу видимого вещества, сосредоточенного в галактиках.

В 70-х гг. обнаружено рентг. излучение горячего газа, заполняющего С. г. Исследование спектра излучения и распределения яркости позволило оценить темп-ру и распределение плотности газа. Оказалось, что в богатых С. г. эти величины хорошо коррелируют со скоростями галактик и их распределением. В более бедных С. г. наряду с общим рентг. фоном выделяется излучение корон отдельных наиб. массивных галактик, гравитационный потенциал к-рых сравним с гравитационным потенциалом скопления как целого. Масса горячего газа в центр. областях С. г. не превосходит неск. процентов виртальной массы скопления, его плотность ок. 10⁻³ см⁻³. Эти данные служат важным независимым подтверждением стационарности С. г. и приведенных выше оценок массы видимого и невидимого вещества в них. Подробные спектральные наблюдения нескольких наиб. ярких С. г. показывают, что в горячем газе присутствуют высокоионизованные тяжелые элементы (напр., Fe²⁶⁺) с относит. содержанием ок. 0,1–0,3 солнечного (см. *Распространенность элементов*). Это значит, что газ С. г. не является первичным и частично прошел переработку в звё-

здах. Однако ныне невозможно сказать, как протекали эволюция горячего газа и его обогащение тяжелыми элементами. Горячий газ в С. г. может наблюдаться также по искажению спектра *микроволнового фонового излучения* — эффект Зельдовича — Сюняева. Эффект связан с рассеянием фотонов этого излучения на электронах горячего газа С. г., что ведёт к росту ср. энергии фотонов и падению темп-ры излучения T в области спектра, где $h\nu < kT$ (ν — частота излучения). Эффект, видимо, наблюдается в двух С. г. Одновременно наблюдается рентг. излучения С. г. и эффекта Зельдовича — Сюняева позволяет точнее оценить параметры С. г., поскольку эти наблюдаемые величины зависят от разных комбинаций темп-ры и плотности газа и размеров скопления.

Наблюдаемая анизотропия форм С. г., вероятно, связана с анизотропией распределения галактик по скоростям. Это свидетельствует о том, что С. г. возникли при объединении уже сформировавшихся галактик и никогда не проходили фазы стационарного газового облака. Такое заключение согласуется с наблюдаемыми особенностями распределения галактик скопления по скоростям. В большинстве С. г. дисперсия скоростей (квадрат среднеквадратичной скорости) не зависит от массы галактик. Это значит, что в системе успели пройти процессы быстрой релаксации скоростей галактик в коллективном гравитационном поле (см. *Звёздная динамика*), но ещё не успело сказаться влияние процессов дальнего взаимодействия, к-рые с течением времени должны привести к максвелловской ф-ции распределения галактик по скоростям с дисперсией скоростей, зависящей от массы галактик (такая зависимость отмечена лишь у неск. плотных С. г.). Это — свидетельство сравнит. молодости С. г.

С. г. наблюдаются вплоть до красных смещений $z \approx 1$ (С. г. 3C184), тогда как квазары найдены вплоть до $z \approx 4$. Поэтому прямых данных об эпохе формирования С. г. наблюдения не дают. Интересно, что хотя близкие квазары часто видят отд. галактик, отмечена отрицательная антикорреляция распределений квазаров и С. г. С. г. являются крайними элементами *крулломасштабной структуры Вселенной*. Изучение окрестностей Галактики показывает, что богатые С. г., как правило, расположены в узлах, в к-рых сходятся неск. цепочек и сверхскоплений галактик. Меньше богатые С. г. часто расположены цепочкой вдоль мощного сверхскопления галактик. Довольно часто С. г., подобно галактикам, образуются в небольшие группы из 2–3 членов. В неск. случаях наблюдаются спящие двух С. г., сопровождаемые мощным рентг. излучением. Определённая на основе наблюдений корреляц. ф-ция распределения С. г.

$$\xi(r) \approx (r/r_c)^{-2,8}, \quad r_c \approx 25h^{-1} \text{ (Мпк)}$$

(r — расстояние между парами С. г., h — безразмерный параметр; см. *Хаббл закон*) по форме подобна корреляц. ф-ции галактик, но отличается от неё значением корреляц. радиуса r_c , прибл. в 5 раз превосходящего принятое значение корреляц. радиуса распределения галактик. Отмечается зависимость значения r_c от класса богатства и объёма выборки. Различные корреляц. радиусы распределения галактик и С. г. частично связано с сильным различием плотности их распределения в пространстве. Подробное изучение и численное моделирование эффекта показывают, что, вероятно, необходимо допустить и добавочное крупномасштабное (~ 50 Мпк) сгущивание вещества, к-рое трудно заметить при изучении распределения галактик.

Модели образования структуры Вселенной, основанные на теории *гравитационной неустойчивости*, в их общих чертах неплохо описывают образование С. г. и их подполюе как элементов крупномасштабной структуры. Более подробное изучение этого процесса методами численного моделирования затруднено из-за большого объёма вычислений. Приближённое описание на базе теории особенностей градиентных отображений (см.

Катастроф теория) и Бюргера уравнения позволяют решать ряд проблем на качественном уровне, но не дают количественных описаний.

Лит.: F a b i a n A. C., «Ann. Rev. Astron. and Astrophys.», 1961, т. 29. А. Г. Дорoshин. **СКОРОСТНОЙ НАПОР** (динамическое давление) — кинетич. энергия единицы объёма идеальной несжимаемой жидкости: $\rho v^2/2$, где ρ — плотность жидкости, v — скорость её течения; входит составной частью в Бернулли уравнение. Измеряется с помощью трубки Пито — Прандтля (см. Трубка измерительная).

СКОРОСТЬ — одна из основных кинематич. характеристик движения точки: $v = dr/dt$, где dr — элементарное перемещение (или приращение радиус-вектора r) точки в данной системе отсчёта за время dt . Направлен вектор v по касательной к траектории в сторону движения точки. По модулю $v = ds/dt$, где ds — элементарный путь точки за время dt .

Измеряют С. обычно в м/с (СИ), см/с (СГС) или км/ч. В проекциях на оси координат компоненты С. имеют следующий вид (см. рис.):



Модуль С. в этих случаях равен квадратному корню из суммы квадратов соответствующих компонент.

Когда говорят о С. произвольного движущегося тела или системы тел, то имеют в виду С. их центра масс. Это есть обобщение С. материальной точки.

В ньютоновской (нерелятивистской) механике С. точки при переходе от одной инерциальной системы отсчёта K' к др. системе K преобразуется по закону

$$v = v' + v_0 \left(v_x = v'_x + v_0, v_y = v'_y, v_z = v'_z \right), \quad (1)$$

где v_0 — скорость K' -системы относительно K -системы. Это т. н. классический закон сложения (преобразования) С., являющийся следствием преобразований Галилея (см. Галилея принцип относительности).

В более сложном случае, когда K' -система совершает произвольное движение относительно K -системы, С. точки преобразуется по ф-ле

$$v = v' + v_0 + [\omega r'],$$

где v_0 — скорость начала отсчёта K' -системы, ω — её угл. скорость, r' — радиус-вектор данной точки относительно начала отсчёта K' -системы.

В относительности теории установлены факт: в природе существует предел скорости c . С. распространения взаимодействий и сигналов (в значит. и тел.). Она равна С. света в вакууме $c = 2,99792458 \cdot 10^8$ м/с. Наличие такой С. существенно меняет закон преобразования С. В соответствии с Лоренца преобразованиями при переходе от K' - к K -системе отсчёта ф-лы преобразования компонент С. приобретают более сложный вид:

$$v_x = \frac{v'_x + v_0}{1 + v'_x v_0/c^2}, v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + v'_y v_0/c^2}, v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + v'_z v_0/c^2}, \quad (2)$$

где $\beta = v_0/c$, v_0 — скорость K' -системы отсчёта относительно K -системы. Классич. закон сложения С.

(1) оказывается несправедливым при релятивистских С. При переходе к нерелятивистским С. преобразованием (2) переходит в (1).

Из преобразований (2) следует, что, напр., фотон, движущийся со скоростью c в K' -системе отсчёта, будет двигаться и относительно K -системы с той же скоростью c — в полном соответствии со 2-м постулатом теории относительности.

Дальнейшими обобщениями понятия С. являются обобщенная скорость (см. Обобщенные координаты) и скорость четырехмерная.

СКОРОСТЬ ЗВУКА — скорость распространения в среде упругой волны. Определяется упругостью и плотностью среды. Для плоской волны, бегущей без изменения формы со скоростью c в направлении осей x, z , звуковое давление p можно представить в виде $p = p(x - ct)$, где t — время. Для плоской гармонич. волны в среде без дисперсии $p = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$. В С. з. выражается через частоту ω и волновое число k ф-лой $c = \omega/k$. Со скоростью c распространяется фаза гармонич. волны, поэтому с наз. также фазовой С. з. В средах, в к-рых форма произвольной волны меняется при распространении, гармонич. волны тем не менее сохраняют свою форму, но фазовая скорость оказывается различной для разных частот, т. е. имеет место дисперсия звука. В этих случаях пользуются также понятием групповой скорости. При больших амплитудах упругой волны появляются нелинейные эффекты (см. Нелинейная акустика), приводящие к изменению любых волн, в т. ч. и гармонических: скорость распространения каждой точки профиля волны зависит от величин давления в этой точке, возрастают с ростом давления, что и приводит к искажению формы волны.

Скорость звука в газах и жидкостях. В газах и жидкостях звук распространяется в виде объёмных волн сжатия — разрежения. Если процесс распространения происходит адиабатически (что, как правило, и имеет место), т. е. изменение темп-ры в звуковой волне не успевает выравниваться и за $1/2$ периода тепло из нагретых (сжатых) участков не успевает перейти к холодным (разреженным), то С. з. равна $c = \sqrt{(\partial p/\partial \rho)}$, где p — давление в веществе, ρ — его плотность, а индекс s показывает, что производная берётся при постоянной энтальпии. Эта С. з. наз. адиабатической. Выраженные для С. з. может быть записано также в одной из следующих форм:

$$c = \sqrt{K_{ад}/\rho} = \sqrt{1/\beta_{ад}\rho} = \sqrt{\gamma/\beta_{из}\rho},$$

где $K_{ад}$ — адиабатич. модуль всестороннего сжатия вещества, $\beta_{ад} = 1/K_{ад} = \rho^{-1}(\partial \rho/\partial p)_s$ — адиабатич. сжимаемость, $\beta_{из} = \gamma \beta_{ад}$ — изотермич. сжимаемость, $\gamma = c_p/c_v$ — отношение теплоёмкостей при постоянных давлении и объёме.

В идеальном газе $c = \sqrt{\gamma p/\rho} = \sqrt{\gamma RT/\mu}$, где $R = 8,31$ Дж/моль·К — универсальная газовая постоянная, T — абс. темп-ра, μ — молекулярная масса газа. Это т. н. д а л а с о в а С. з. В газе она совпадает по порядку величины со средней тепловой скоростью движения молекул. Величину $c' = \sqrt{p/\rho}$ называют в эт. о н о в о й С. з., она определяет С. з. при изотермич. процессе распространения, к-рый может иметь место на очень низких частотах. В большинстве случаев С. з. соответствует лапласову значению.

С. з. в газах меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях, как правило, меньше, чем в твёрдых телах. В табл. 1 и 2 приведены значения С. з. для нек-рых газов и жидкостей, причём в тех случаях, когда имеется дисперсия, приведены значения С. з. для частот, меньших, чем частота релаксации.

В идеальных газах при заданной темп-ре С. з. не зависит от давления и растёт с ростом темп-ры как \sqrt{T} . Изменение С. з. равно $\Delta c/\Delta T = c/2T$, где Δc и ΔT — малые приращения скорости и темп-ры по сравнению

Табл. 1.—Скорость звука в некоторых газах при °С*

	с, м/с
Азот	334
Икселод	316
Воздух	331
Гелий	965
Водород	1284
Неон	435
Метан	430
Аммиак	415
Углекислый газ	259
Иодистый водород	157

* Значения скорости даны для нормального давления.

Табл. 2.—Скорость звука в некоторых жидкостях при 20 °С

	с, м/с
Вода	1490
Ацетон	1190
Бензол	1324
Спирт этиловый	1180
Толуол	1324
Четырёххлористый углерод	920
Ртуть	1453
Глицерин	1923

Эти зависимости имеют сложный вид. Для расчёта С. з. в море используются таблицы, рассчитанные по эмпирич. ф-лам. Поскольку темп-ра, давление, а иногда и солёность меняются с глубиной, то С. з. в океане является ф-цией глубины (с). Эта зависимость существенно определяет характер распространения звука в океане (см. *Гидроакустика*). В частности, она определяет существование *подводного звукового канала*, положение оси к-рого и др. характеристики зависят от времени года, времени суток и от географич. местоположения.

В сжиженных газах С. з. увеличивается при той же темп-ре: напр., в газообразном азоте при темп-ре —195 °С она равна 176 м/с, в жидком азоте при той же темп-ре 859 м/с, в газообразном и жидком гелии при —269 °С соответственно 102 м/с и 198 м/с.

С. з. в смесях газов или жидкостей зависит от концентрации компонент. В газовых смесях С. з. хорошо описывается ф-лой $c = \sqrt{\gamma RT/\mu}$, в к-рой в качестве μ вята молекулярная масса смеси, определяемая молекулярными массами компонентов с учётом их концентрации. В жидких смесях зависимость С. з. от концентрации компонентов имеет довольно сложный характер, к-рый связан с видом межмолекулярных взаимодействий. Так, в спиртоводных и кислотоводных смесях при нек-рой концентрации имеется максимум С. з., а в таких смесях, как ацетон с сероуглеродом, бензол с четырёххлористым углеродом и др., при нек-рой концентрации С. з. имеет минимум. В водных растворах солей С. з. растёт с ростом концентрации во всем интервале концентраций. Т. о., измерение С. з. может использоваться для определения и контроля концентрации компонент смесей и растворов.

В жидком гелии С. з. увеличивается при понижении темп-ры. При фазовом переходе в сверхтекучее состояние возникает излом на кривой зависимости С. з. от темп-ры.

В многоатомных газах и практически во всех жидкостях имеется дисперсия С. з., причём в жидкостях она проявляется на высоких УЗ- и гиперзвуковых частотах.

В резинах, полимерах и каучуках С. з. зависит от хим. состава и плотности упаковки макромолекул и растёт с увеличением частоты; в материалах этого типа с меньшей плотностью и С. з. меньше, напр. в силико-

с их значениями с и Т. При комнатной темп-ре отност. изменение С. з. в воздухе составляет примерно 0,17% на 1 К. В жидкостях С. з., как правило, уменьшается с ростом темп-ры и изменение её составляет, напр., для ацетона —5,5 м/с К, для этилового спирта —3,6 м/с К. Исключением из этого правила является вода, в к-рой С. з. при комнатной темп-ре увеличивается с ростом темп-ры на 2,5 м/с К, достигает максимума при темп-ре ~74 °С и с дальнейшим ростом темп-ры уменьшается. С. з. в воде растёт с увеличением давления примерно на 0,01% на 1 атм, а также с увеличением содержания растворённых в ней солей.

В морской воде С. з. зависит от темп-ры, солёности и глубины.

новом каучуке С. з. составляет 950—1100 м/с на частотах 20—150 мкГц, в бутадие-нитрильном каучуке 1600—2100 м/с в том же диапазоне частот.

Скорость звука в твёрдых телах. В неограниченной твёрдой среде распространяются продольные и сдвиговые (поперечные) упругие волны. В изотропном твёрдом теле фазовая скорость для продольной волны

$$c_l = \sqrt{E(1-\nu)/\rho(1+\nu)(1-2\nu)} = \sqrt{(K+4/3)G/\rho},$$

для сдвиговой волны

$$c_t = \sqrt{E/2\rho(1+\nu)} = \sqrt{G/\rho},$$

где E — модуль Юнга, G — модуль сдвига, ν — коэф. Пуассона, K — модуль объёмного сжатия. Скорость распространения продольных волн всегда больше, чем скорость сдвиговых волн, причём обычно выполняется соотношение $c_l > c_t/\sqrt{2}$. Значения c_l и c_t для нек-рых изотропных твёрдых тел приведены в табл. 3.

Табл. 3.—Скорость звука в некоторых изотропных твёрдых телах

	c_l , м/с	c_t , м/с	c_{sl} , м/с
Кварц плавленый	5970	3782	5760
Бетон	4200—5300	—	—
Плавленый	2570—2880	1500—1121	1840—2140
Полиэтилен	2350—2380	1123	1860—2240
Отекло прессн.	5840	3280	5170
Стекло крош.	5100—8120	2840—3550	4540—5300
Стекло флинт	3780—4800	2380—2580	3490—4550
Топол	134	—	—
Эбонит	2405	—	—
Железо	5835—5950	3180—3240	5000—5200
Золото	3200—3240	1200	2630
Магний	5785	3085	4500—4970
Платина	3220—3260	1670—1730	2690—2800
Свинец	1960—2400	700—790	1200—1328
Цинк	4170—4210	2440	3700—3850
Литий	5830	2380	4785—4970
Серебро	3650—3700	1600—1690	2610—2800
Углеродистые ота-	—	—	5090—5177
Негеммаюрал	—	—	—
сталь IX18H9T	—	—	5039
Титан BT-1	—	—	5072
Медь В-2	—	—	3843
Датум 159	4600	2080	3450
Алюминиевый сплав АМГ	6320	3190	5260

В монокристаллах С. з. зависит от направления распространения волны в кристалле (см. *Кристаллоакустика*). В тех направлениях, в к-рых возможно распространение чисто продольных и чисто поперечных волн, в общем случае имеется одно значение c_l и два значения c_t . Если значения c_l различны, то соответствующие волны иногда наа. быстрой и медленной поперечными волнами. В общем случае для каждого направления распространения волны в кристалле могут существовать три смешанные волны с разными скоростями распространения, к-рые определяются соответствующими комбинациями модулей упругости, причём векторы колеб. смещений частиц в этих трёх волнах взаимно перпендикулярны. В табл. 4 приведены значения С. з. для нек-рых монокристаллов в характерных направлениях.

Во мн. веществах С. з. зависит от наличия посторонних примесей. В полупроводниках и диэлектриках С. з. чувствительна к концентрации примесей; так, при легировании полупроводника примесью, увеличивающей число носителей тока, С. з. уменьшается с увеличением концентрации; при увеличении темп-ры С. з. слабо увеличивается.

В металлах и сплавах С. з. существенно зависит от предшествующей механической и термообработки: прокат,ковка, отжиг и т. п. Частично это явление связано с дислокациями, наличие к-рых также влияет на С. з.

СКОРОСТЬ

Табл. 4 — Скорость звука в некоторых монокристаллах

	Направление распространения	Тип волны	c , м/с
Кварц (SiO_2)	Вдоль оси z	Продольная	6330
	—	Поперечная	4820
	Вдоль оси x	Продольная	5600
	—	Поперечная	5050
Рубин (Al_2O_3)	—	Быстрая	3500
	—	Медленная	3500
Рубин (Al_2O_3)	Вдоль оси C	Продольная	11240
	—	Поперечная	7800
Ниобат лития (LiNbO_3)	Вдоль оси C	Продольная	7330
	—	—	—
Сульфид кадмия (CdS)	Вдоль оси C	Поперечная	3580
	—	Продольная	4500
Железосодержащий гранат ($\text{Y}_2\text{Fe}_2\text{O}_7$)	Вдоль оси x	Поперечная	1860
	—	Поперечная	3840
Алюминативная шпинель (MgAl_2O_4)	Вдоль оси [100]	Продольная	8830
	—	—	—
	Вдоль оси [111]	Продольная	6540
	—	Поперечная	10980
—	—	Поперечная	5100

В металлах, как правило, C , з. уменьшается с ростом темп-ры. При переходе металла в сверхпроводящее состояние характер зависимости иной: величина $c_{\text{дл}}/c_{\text{т}}$ в точке перехода меняет знак. В сильных магн. полях проявляются некр-ые эффекты в зависимости C , з. от магн. поля, к-рые отражают особенности поведения электронов в монокристалле направленным в кристалле появляясь осцилляциями C , з. как ф-ция магн. поля. Измерения зависимости C , з. от магн. поля являются чувств. методом исследования внутр. структуры металлов.

В аьзоэлектриках и сегнетовых кристаллах наличие электромагнит. связи приводит к уменьшению модулей упругости и, следовательно, уменьшается C , з.

Аналогичное явление наблюдается и в магнетострикционных материалах, где наличие магнитоупругой связи приводит, кроме того, к появлению заметной зависимости C , з. от напряженности магн. поля, обусловленной т. н. ΔE -эффектом, т. е. зависимостью модуля Юнга E от величины магн. поля H . Изменения C , з. с ростом H могут достигать неск. процентов (иногда до десятков процентов). Такая же зависимость C , з. от напряженности электрич. поля наблюдается в сегнетовых кристаллах. При действии на твердое тело статич. механич. напряжений C , з. зависит от величины этих напряжений, что является следствием отклонения от линейного закона Гука.

В ограниченных твердых телах кроме продольных и поперечных волн имеются и др. типы волн. Так, вдоль свободной поверхности твердого тела или вдоль границы его с др. средой распространяются *поверхностные акустические волны*, скорость к-рых меньше скорости объемных волн, характерных для данного материала. Для пластины, стержней и др. твердых акустич. волноводов характерны *нормальные волны*, скорость к-рых определяется не только свойствами вещества, но и геометрией тела. Так, напр., C , з. для продольной волны в стержне $c_{\text{ст}}$, поперечные размеры к-рого много меньше длины волны звука, отличается от C , з. в неограниченной среде c_1 (табл. 3):

$$c_{\text{ст}} = \sqrt{E/\rho}.$$

Методы измерения C , з. можно подразделить на резонансные, интерферометрические, импульсные и оптические (см. *Дифракция света на ультразвуке*). Наиб. точности измерения достигают с помощью импульсно-фазовых методов. Опт. методы дают возможность измерять C , з. на гиперзвуковых частотах (вплоть до

10^{11} — 10^{12} Гц). Точность абс. измерений C , з. на лучшей аппаратуре ок. $10^{-3}\%$, тогда как точность относит. измерений порядка $10^{-5}\%$ (напр. при изучении зависимости c от темп-ры или магн. поля или от концентрации примесей или дефектов).

Измерения C , з. используются для определения мн. свойств вещества, таких, как величина отношения теплоемкостей для газов, сжимаемости газов и жидкостей, модулей упругости твердых тел, дебаевской темп-ры и др. (см. *Молекулярная акустика*). Определение малых изменений C , з. является чувствит. методом фиксации примесей в газах и жидкостях. В твердых телах измерение C , з. и её зависимости от разл. факторов (темп-ры, магн. поля и др.) позволяет исследовать строение вещества: зонную структуру полупроводников, строение поверхности Ферми в металлах и пр.

Лит.: Ландау Я. Д., Лифшиц Е. М., Теория упругости, 4 изд., М., 1987; их же, Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; Бергтрам Я. Л., Ультразвук и его применение в акуст. технике, пер. с англ., 2 изд., М., 1957; Митгайлов И. Г., Соловьев В. А., Сырников Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964; Таблицы для расчета скорости звука в морской воде, Л., 1965; Физическая акустика, под ред. У. Моллона, пер. с англ., т. 1, ч. А, М., 1966, гл. 4; т. 2, ч. Б, М., 1970, гл. 7; Колесников А. Е., Ультразвуковые измерения, 2 изд., М., 1982; Труэлл Р., Зальбаум Ч., Чин Б., Ультразвуковые методы в физике твердого тела, пер. с англ., М., 1972; Акустические кристаллы, под ред. М. П. Шапошниковой, М., 1982; Красильникова В. А., Крылов В. В., Введение в физическую акустику, М., 1984. А. Л. Поляков.

СКОРОСТЬ СВЕТА в свободном пространстве (вакууме) — скорость распространения любых электромагнитных волн (в т. ч. световых); одна из фундам. физ. постоянных; представляет собой предельную скорость распространения любых физ. воздействий (см. *Относительности теория*) и инвариантна при переходе от одной системы отсчета к другой.

C , с. в среде c' зависит от показателя преломления среды n , различного для разных частот у излучения (*Дисперсия света*): $c'(\nu) = c/n(\nu)$. Эта зависимость приводит к отличию *групповой скорости* от *фазовой скорости* света в среде, если речь идет не о монохромат. свете (для C , с. в вакууме эти две величины совпадают). Экспериментально определяя c' , всегда измеряют групповую C , с. либо т. н. скорость сигнала, или скорость передачи энергии и, только в нек-рых спец. случаях по равную групповую.

Впервые C , с. определял в 1676 О. К. Рёмер (O. Ch. Roemer) по изменению промежутков времени между затмениями спутников Юпитера. В 1728 её установил Дж. Брайдль (J. Bradley), исходя из своих наблюдений абберации света звезд. В 1849 А. И. Л. Фуко (A. H. L. Fizeau) первым измерил C , с. по времени прохождения светом точно известного расстояния (базы); т. к. показатель преломления воздуха очень мало отличается от 1, то наземные измерения дают величину, весьма близкую к C . В опыте Фуко пучок света от источника S (рис. 1), отраженный полупрозрачным

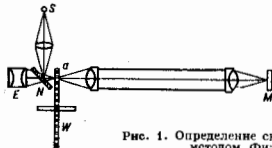


Рис. 1. Определение скорости света методом Фуко.

зеркалом N , периодически прерывался вращающимся зубчатым диском W , проходил базу MN (ок. 8 км) и, отразившись от зеркала M , возвращался к диску. Попадая на зубец, свет не достигал наблюдателя, а понаправив в промежуток между зубцами свет можно было наблюдать через окуляр E . По известным скоростям вращения диска определялось время прохождения светом базы. Фуко получил значение $c = 313300$ км/с. В 1862 Ж. Б. Л. Фуко (J. B. L. Foucault) реализовал

высказанную в 1838 идею Д. Араго (D. Arago), применяв вместо зубчатого диска быстровращающееся (512 об/с) зеркало. Отражаясь от зеркала, пучок света направлялся на базу и по возвращении вновь попадал на это же зеркало, успевшее повернуться на некоторый малый угол (рис. 2). При базе всего в 20 м Фуко нашёл,

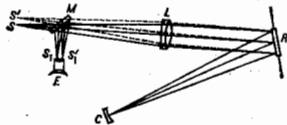


рис. 2. Определение скорости света методом вращающегося зеркала (методом Фуко): S — источник света; R — быстровращающееся зеркало; C — неподвижное возмущенное зеркало, центр которого совпадает с осью вращения R (поступо свет, отражённый C , всегда попадает обратно на R); M — полупрозрачное зеркало; L — объектив; E — окуляр; RC — точно измеренное расстояние (база). Пунктиром показано положение R , вращающееся за время прохождения светом пути RS и обратно, и обратный ход пучка лучей через объектив L , который собирает отражённый пучок в точке S' , а не вновь в точке S , как это было бы при неподвижном зеркале R . Скорость света устанавливается, измеряя смещение SS' .

что C . с. равна 298000 ± 500 км/с. Схемы и осн. идеи опытов Физо и Фуко были многократно использованы в последующих работах по определению C . с. Получено А. Майкельсоном (A. Michelson) (см. Майкельсона опыт) в 1926 значение $c = 299796 \pm 4$ км/с было тогда самым точным и вошло в 19-й вариант таблицы физ. величин.

Измерения C . с. в 19 в. сыграли большую роль в физике. Дополнительно подтвердив волновую теорию света. Выполненное Фуко в 1850 сравнение C . с. одной и той же частоты ν в воздухе и воде показало, что скорость в воде $v = c/n(\nu)$ в соответствии с предсказанием волновой теории. Была также установлена связь оптики с теорией электромагнетизма: измеренная C . с. совпала со скоростью эл.-магн. волн, вычисленной из отношения эл.-магн. и эл.-статич. единиц электрич. заряда (ошаты В. Вебера (W. Weber) и Ф. Кольрауша (F. Kohlrausch) в 1856 и последующие более точные измерения Дж. К. Максвелла (J. C. Maxwell)). Это совпадение явилось одним из отрывных пунктов при создании Максвеллом в 1864—73 эл.-магн. теории света.

В совр. измерениях C . с. используется модернизированный метод Физо (модуляц. метод) с заменой зубчатого колеса на эл.-оптич., дифракц., интерференционный или к-л. иной модулятор света, полностью проницающий или ослабляющий световой пучок (см. Модуляция света). Приёмником излучения служит фотозелент или фотоэлектронный умножитель. Применение лазера в качестве источника света, УЭ-модулятора со стабилизиров. частотой и повышение точности измерения длины базм позволили снизить погрешности измерений и получить значение $c = 299792,5 \pm 0,15$ км/с. Помимо прямых измерений C . с. по времени прохождения известной базы, широко применяются косвенные методы, дающие большую точность. Так, с помощью микроволнового вакуумиров. резонатора [К. Фрум (K. Froome), 1958] при длине волны излучения $\lambda = 4$ см получено значение $c = 299792,5 \pm 0,1$ км/с. С ещё меньшей погрешностью определяется C . с. как частное от деления независимо найденных λ и ν атомарных или молекулярных спектральных линий. К. Ивенсон (K. Eversen) и его соотрудники в 1972 по цезиевому стандарту частоты (см. Квантовые стандарты частоты) и калиб с точностью до 11-го знака частоту излучения CH_2 -лазера, а по криптоновому стандарту частоты — его длины волны (ок. 3,39 мкм) и получили $c = 299792456,2 \pm 0,8$ м/с. Решением Генеральной ассамблеи Международного комитета по численным данным для науки и техники — КОДАТА (1973), проанализированной все имеющиеся данные, их достоверности и погрешности,

C . с. в вакууме принято считать равной $299792458 \pm 1,2$ м/с.

Как можно более точное измерение величин с чрезвычайно важно не только в общетеоретич. плане и для определения значений др. физ. величин, но и для практич. целей. К ним, в частности, относится определение расстояний по времени прохождения радиолокационных световых сигналов в радиолокации, оптической локации, светодальнометрии, в системах слежения ИСЗ и др.

Лит.: Вафа и др. В. Г. Попов Ю. В. Скорость света и ее значение в науке и технике, Минск, 1970; Тейлор Б. Паркер В., Лангеберг Д., Фундаментальные константы и квантовая электродинамика, пер. с англ., М., 1972. А. М. Бонч-Бруевич.

СКОРОСТЬ ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ в теории относительности — обобщение понятия обычной (трёхмерной) скорости. C . ч. — четырёхмерный вектор с компонентами $u_i = dx_i/dt$, $i = 1, 2, 3, 4$, где x_i — координаты Минковского ($x_1 = x$, $x_2 = z$, $x_3 = ict$), dt — элемент собственного времени движущейся частицы. Компоненты C . ч. связаны с проекциями u_x , u_y , u_z трёхмерной скорости и соотношениями:

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{u_x}{\sqrt{1-u^2/c^2}}; & u_2 &= \frac{u_y}{\sqrt{1-u^2/c^2}}; \\ u_3 &= \frac{u_z}{\sqrt{1-u^2/c^2}}; & u_4 &= \frac{ic}{\sqrt{1-u^2/c^2}}. \end{aligned} \quad (1)$$

C . ч. — времениподобный вектор, т. к. $\sum u_i^2 = -c^2$.

Значения C . ч. в двух галилеевских системах отсчёта K и K' связаны Лоренца преобразованиями:

$$u'_1 = \frac{u_1 + \beta u_4}{\sqrt{1-\beta^2}}; \quad u'_2 = u_2; \quad u'_3 = u_3; \quad u'_4 = \frac{u_4 - \beta u_1}{\sqrt{1-\beta^2}},$$

где $\beta = v/c$ (v — плоскост. скорость системы отсчёта K' и R'). См. Относительности теория.

СКРЫТАЯ МАССА — труднонаблюдаемые формы вещества, выявляемые по их гравитацион. воздействию на движение и структуру галактик, скоплений и сверхскоплений галактик. Предполагается, что существует несколько (два или более) видов M_c , отличающихся массой частиц и др. свойствами. Наб. надёжно C . м. фиксируется в скоплениях галактик и в коронах отд. галактик. Надёжных наблюд. данных о C . м. в сверхскоплениях галактик нет.

В скоплениях галактик кроме видимой массы M_v , определяемой по общей светимости всех галактик скопления и средней массе — светимости зависимости для галактик, можно найти динамич. (виральную) массу M_d , определяемую с помощью виральной теоремы по наблюдаемой дисперсии скоростей галактик скопления. Оценки динамич. массы M_d подтверждают наблюдения рентг. излучения горячего межгалактич. газа скоплений, что позволяет получить независимые оценки темп-ры газа и тем самым — гравитацион. потенциала и массы скопления. Для богатых скоплений динамич. масса M_d примерно в 10—20 раз превосходит видимую массу галактик M_v .

Наблюдения кривых вращения [зависимостей скорости вращения v_c вещества галактики от расстояния r до центра галактики (см. Вращение галактики)] для ряда галактик позволяют найти распределение массы галактики по радиусу с помощью соотношения

$$v_c^2/r = GM(r)/r^2,$$

где v_c^2/r — центробежное ускорение при круговом движении, $GM(r)/r^2$ — гравитацион. ускорение, вызываемое массой $M(r)$, расположенной внутри орбиты радиуса r . Кривые вращения наблюдаются как оптич. методами, так и в радиолонии нейтрального водорода 21 см за пределами видимой галактики. Анализ кривых вращения показывает, что в ряде галактик за пределами видимо-

го распределения звёзд существует протяжённая массивная корона невидимого вещества, в ряде случаев в десятки раз превосходящая массу светящейся составляющей (звёзды, газ, пыль и др.).

При изучении движения звёзд внутри Галактики (в окрестности Солнца) установлено, что плотность С. м. в этой области не превосходит плотности видимого вещества, но может быть сравнима с ней. Попытки обнаружения С. м. в маломассивных галактиках пока не дали определённых результатов.

В космологии допущение С. м. (космологич. С. м.) необходимо для того, чтобы согласовать получаемые разл. путями оценки ср. плотности вещества во Вселенной. Прямые наблюдат. оценки плотности видимого вещества ρ_v приводят к значению $\Omega_v = \rho_v/\rho_c \approx 0,01-0,03$ (ρ_c — критич. плотность Вселенной, соответствующая границе между открытой и закрытой моделями Вселенной). По данным о хим. составе первичного вещества можно оценить плотность ρ_b барьонной составляющей Вселенной, $\Omega_b \equiv \rho_b/\rho_c \lesssim 0,1$. Совместный анализ процессов образования наблюдаемой крупномасштабной структуры Вселенной и процессов образования флуктуаций температуры микроволнового фонового излучения приводит к выводу, что полная плотность Вселенной ρ_t должна быть высока, $\Omega_t \equiv \rho_t/\rho_c \approx 1$. Кроме того, гл. вклад в полную плотность должны давать частицы, не взаимодействующие с микроволновым фономым излучением. Оценка $\Omega_t \approx 1$ хорошо согласуется с совр. моделями ранней Вселенной (см. Работы *входящая Вселенная*).

Теория суперравнощации, суперструн и др. предполагают существование обширной группы труднонаблюдаемых частиц, часть из к-рых может входить в состав С. м. Наиб. активно обсуждается возможность связать космологич. С. м. с частицами типа аксионов, обладающими «эффективной» массой $m \approx 10$ МэВ, а также с нестабильными слабо взаимодействующими с веществом частицами типа нейтрино с массой $m \approx 100$ эВ и временем жизни $\tau = 10^8-10^9$ лет. Очень перспективны попытки связать свойства этих частиц с существованием трёх поколений кварков и лептонов (см. *Поколения фермионов*). С. м. галактик и скоплений галактик связана с более массивными частицами неизвестной природы.

А. Г. Дорощевич.

СКРЫТЫЕ ПАРАМЕТРЫ — гипотетич. дополнит. переменные, неизвестные в настоящее время, значения к-рых должны полностью характеризовать состоящие системы и определять её будущее либо поле, чем квантовомеханич. вектор состояния. Полагают, что с помощью С. п. от статистич. описания микробъектов можно перейти к динамич. закономерностям, при к-рых однозначны связаны во времени сами фич. величины, а не их статистич. распределения (см. *Причинность*). С. п. обычно считают разл. поля или координаты и импульсы более мелких, составных частей квантовых частиц. Однако после открытия кварков (составных частиц адронов) оказалось, что их поведение подчиняется квантовой механике, как и поведение самих адронов [1].

Согласно теореме фон Неймана, ни одна теория со С. п. не может воспроизвести все следствия квантовой механики, однако, как впоследствии выяснилось, доказательство Дж. фон Неймана (J. von Neumann) было основано на предположениях, вообще говоря, необязательных для любой модели С. п. [2]. Весомый аргумент в пользу существования С. п. выдвинули А. Эйнштейн (A. Einstein), Б. Подольский (B. Podolsky) и Н. Розен (N. Rosen) в 1935 (т. и. *Эйнштейна — Подольского — Розена парадокс*), сущность к-рого в том, что нек-рые характеристики квантовых частиц (в частности, проекция спина) можно измерять, не подвергая частицы силовому воздействию. Новым стимулом к эксперим. проверке парадокса Эйнштейна — Подольского — Розена стали доказательства в 1951 *Велла неравенства* [2], к-рые дали возможность прямой эксперим.

верки гипотезы о С. п. Эта неравенства демонстрируют отличие предсказаний квантовой механики от любых теорий С. п., не допускающих существования физ. процессов, распространяющихся со сверхсветовой скоростью. Поставленные в ряде лабораторий мира эксперименты подтвердили предсказания квантовой механики о существовании более сильных корреляций между частями, чем предсказывают любые локальные теории С. п. Согласно этим теориям, результаты эксперимента, проведённого над одной из частей, определяются только самими этими экспериментом и не зависят от результатов эксперимента, к-рый может проводиться над др. частями, не связанной с первой силовыми взаимодействиями.

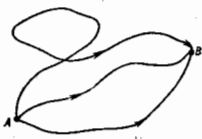
Лит.: 1) Сайберн А. Квантовая механика и физика элементарных частиц, пер. с англ., М., 1989; 2) Грив А. А., Неравенства Белла и экспериментальная проверка квантовых корреляций на макроскопических расстояниях, *ЭФН*, 1984, т. 142, с. 619; 3) Спасский В. И., Москоцкий В. А., В. О. Мелюцкий в квантовой физике, *УФН*, 1984, т. 142, с. 589; 4) Вом Д. О возможности интерпретации квантовой механики на основе представлений о «скрытых» параметрах, *УФН*, 1955, об.; Вопросы причинности в квантовой механике, М., 1955, с. 34.

СЛАБАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ — совокупность явлений, обусловленных квантовой интерференцией электронов проводимости в проводниках с металлич. типом проводимости, т. е. обладающих остаточной проводимостью (см. *Металлы*). Эффекты С. л. универсальны и проявляются в любых *неупорядоченных системах* — *слабоупорядоченных полупроводниках*, *металлах*, *стёклах* (см. *Аморфные металлы*), *системах с думерным электронным газом*, тонких металлах, плёнках и т. д. При темп-рах, столь низких, что сопротивление проводника определяется рассеянием электронов на случайном потенциале, создаваемом, напр., хвостаческими расположенными примесями (см. *Рассеяние носителей заряда*), квантовая интерференция приводит к поправкам к классич. электропроводности. Последнюю рассчитывают на основе *кинетической уравнения Больцмана*, при выводе к-рого предполагается, что между соударениями электрон движется по классич. траектории и рассеяние на разл. центрах происходит независимо. К С. л. приводит изменение скорости диффузии электронов за счёт интерференции электронных волн, многократно рассеиваемых *дефектами* кристаллич. решетки.

Происхождение термина «С. л.» объясняется тем, что интерференц. явления можно интерпретировать как предельный адиабатический *переход металла — диэлектрика*, при к-ром благодаря достаточно сильному беспорядку происходит полная локализация электронных волн (см. *Андерсоновская локализация*). Вдали от перехода квантовые поправки малы по параметру l/λ , где λ — длина волны электрона, l — длина его свободного пробега. Однако во мн. случаях именно они определяют нетривиальную зависимость проводимости от магн. поля H , темп-ры T , частоты ω перемен. полей и размерности d образца.

Квантовые интерференционные поправки. Полное включение поправок производится с помощью методов *квантовой теории поля*. Однако их происхождение и осн. свойства можно понять на основе следствующих рассуждений. Рассмотрим проводник, в к-ром $l \gg \lambda$, и предположим, что за время t электрон, испытывая рассеяние на примесях, переходит из точки A в точку B . При этом он может пройти по разным путям (рис.). Согласно общим принципам квантовой механики, вероятность такого процесса W определяется выражением:

$$W = \left| \sum_i A_i \right|^2 = \sum_i |A_i|^2 + \sum_{i \neq j} A_i A_j^* \quad (1)$$



Здесь A_i — амплитуда вероятности движения электронов вдоль i -го пути. Первое слагаемое в (1) описывает сумму вероятностей прохождения каждого пути, а второе — интерференцию разных амплитуд. Интерференция большинства амплитуд не даёт вклад в W , т. к. их фазы пропорциональны длине траектории и при суммировании взаимно погашаются. Исключение составляет траектория с самопересечением. Каждой такой траектории можно сопоставить две амплитуды A_1 и A_2 , отвечающие разл. направлениям обхода замкнутой петли. Эти две амплитуды когерентны друг другу, и поэтому их интерференция нельзя пренебречь: $A_1 A_2^* + A_2 A_1^* = 2|A_i|^2$. Пренебрежение интерференцией отвечает классич. описанию (ур-ние Больцмана), а её учёт приводит к возникновению квантовых поправок.

Влияние квантовых поправок на электропроводимость. Относ. величина вклада поправок в проводимость $\Delta\sigma$ (она всегда отрицательна) пропорциональна вероятности самопересечения лучевой трубки с сечением λ^2 при диффузии за время τ_p полного разрушения когерентности (собой фазы) из-за неупругих процессов или из-за рассеяния с переворотом спина. Оценка $\Delta\sigma$, полученная из приведенных рассуждений, по порядку величины совпадает с результатами точного расчёта и определяется выражением:

$$\Delta\sigma = -\frac{e^2}{\lambda} \begin{cases} L_p, & d=1, \\ \ln L_p/l, & d=2, \\ \text{const} \cdot L_p^{-1}, & d=3. \end{cases} \quad (2)$$

Здесь $L_p = \sqrt{D\tau_p}$, D — коэф. классич. диффузии. Из (2) видно, что $\Delta\sigma$ мала по параметру λ/l , но определяет сингулярные зависимости проводимости от темп-ры ($\tau_p \propto T^{-1}$) или частоты поля (при $\omega\tau \gg 1$, τ следует заменить на ω^{-1}).

Влияние неупругого рассеяния. Если доминирующим процессом сбой фазы является неупругое рассеяние, то τ_p растёт с понижением T и всё большее число петлеобразных участков траекторий с размерами $L \leq L_p$ даёт вклад в $\Delta\sigma$. При этом абс. величина $\Delta\sigma$ увеличивается, а сама проводимость уменьшается согласно (2). Этим, в частности, объясняется появление минимума на температурной зависимости сопротивления металлов, плёнок и вырожденных полупроводников. Рост сопротивления при понижении T — результат совместного проявления поправок равной природы, возникающих как за счёт эффектов С. д., так и межэлектронного взаимодействия.

Во внеш. магн. поле амплитуды A_1 и A_2 приобретают доп. фазовый множитель $\exp(\pm i\Phi/\Phi_0)$, где Φ — поток магн. поля через замкнутую петлю, $\Phi_0 = ehc/l$ — квант магн. потока, \pm соответствует разл. направлениям обхода петли. В результате у интерферирующих амплитуд возникает разность фаз $\Delta\Phi_M = 2\Phi/\Phi_0$. Появление $\Delta\Phi_M$ приводит к разрушению когерентности и уменьшению $|\Delta\sigma|$, т. е. к увеличению проводимости. Экспериментально это явление наблюдалось в виде отрицат. магнетосопротивления в слабом магн. поле. Лит.: Ларсен А. И., Хеллманн В. и Э. Е., Андерсоновская локализация и аномальное магнетосопротивление при низких температурах, «УФН», 1982, т. 136, № 3, с. 536; Altshuler В. L., Aronov А. G., Electron-electron interaction in disordered conductors, в кн.: Electron-electron interaction in disordered systems, ed. by A. L. Efros, M. Pollak, Ann., 1985; Sharvin Yu. V., Sharvin D. Yu., Weak electron localization and magnetoresistance oscillations of cylindrical normal metal films, в кн.: Low temperature physics advances in science and technology in the USSR (IST), Physics Series, ed. A. S. Borovik-Romanov, MIR Publishers, Moscow, 1985, p. 240; Aronov А. А., Основы теории металлов, М., 1987; Altshuler В. L. и др., Quantum effects in disordered metal films, «Физ. Сб. Rev. Ser. A Phys. Rev.», 1987, v. 9, p. 223.

СЛАВАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ — совокупность явлений, происходящих в слабосвязанных сверхпроводящих системах (неоднородных сверхпроводящих струк-

турах), содержащих узкие (в направлении протекания тока) области либо области, у к-рых сверхпроводимость отсутствует или сильно подавлена. Термин «С. с.» введён Ф. Андерсоном (Ph. Anderson, 1964), т. к. критический ток и критическое магнитное поле в слабосвязанных сверхпроводниках значительно меньше, чем в обычных. С. с. наблюдается в туннельных контактах [два сверхпроводника разделены тонкой (~ 10 Å) диэлектрич. прослойкой], контактах с прослойкой из нормального (несверхпроводящего) металла и полупроводника, сверхпроводящих мостиках с сужением, точечных контактах, гранулах сверхпроводников, состоящих из большого числа джозефсоновских контактов (рис. 1).

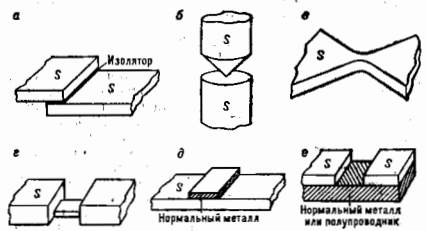


Рис. 1. Слабосвязанные сверхпроводники различных типов: а — туннельный джозефсоновский контакт; б — точечный контакт; в — мостик переменной толщины; г — плёнка из сверхпроводника с узкой полоской нормального металла; е — две близко расположенные плёнки, нанесённые на плёнку из нормального полупроводника.

Впервые С. с. наблюдали в туннельных контактах. В таких структурах электроны могут проходить через диэлектрич. барьер (см. Туннельный эффект), что приводит к возникновению одночастичного туннельного тока (одночастичное тунелирование и в). Резкие изменения одночастичного тока, связанные с особенностями в плотности состояний сверхпроводников, проявляются на вольт-амперной характеристике (ВАХ) при напряжениях на контакте $eV = \Delta_1 \pm \Delta_2$ и $eV = |\Delta_1 - \Delta_2|$, где Δ_1 , Δ_2 — значения сверхпроводящих щелей двух разл. сверхпроводников, образующих контакт (рис. 2).

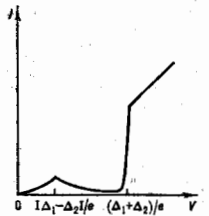


Рис. 2. Вольт-амперная характеристика туннельного контакта в случае одночастичного тока.

Наиб. интерес в С. с. представляет открытие Б. Джозефсона (В. Josephson) в 1962 протекание слабого тока без падения напряжения в туннельных контактах (сверхпроводящий ток куперовских пар, стационарный Джозефсонов эффект). Макс. ток, к-рый может проходить через туннельный контакт, когда напряжение на нём $V = 0$, назв. критич. током контакта I_c . Полный ток через контакт $I = I_c \sin \phi$, где ϕ — джозефсоновская фаза. Если к контакту прикладывается напряжение $V \neq 0$, то ток куперовских пар становится перемен-

ным и осциллирует с частотой ω , связанной с напряжением V соотношением Джозефсона $\omega = 2eV/\hbar$ (не-стационарный эффект Джозефсона). Такой перем. ток приводит либо к генерации излучения на контакте, либо к появлению ступенек на ВАХ при облучении джозефсоновского контакта СВЧ-излучением.

Необычно происходит изменение критич. тока туннельного контакта I_c при приложении магн. поля H . Если ширина контакта L мала (L по сравнению с джозефсоновской глубиной проникновения $\lambda_J = c\Phi_0/8\pi d_1 d_2 v$, где d_1, d_2 — плотности критич. тока; d — толщина области, в к-рую проникает маг. поле; Φ_0 — квант магнитного потока), то поле H проникает в область контакта однородно, а зависимость критич. тока от приложенного магн. поля описывается ф-цией, характерной для Фраунгоферовой дифракц. картины:

$$I_c(H) = I_c(0) \left| \frac{\sin(\pi\Phi/\Phi_0)}{\pi\Phi/\Phi_0} \right|,$$

где $\Phi = HLD$. Если напряжение отлично от нуля, то в присутствии магн. поля в контакте могут распро-

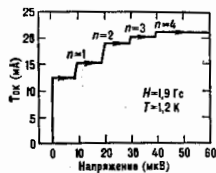


Рис. 3. Типичная картина ступеней Физе на контакте Sn — SnO₂ — Sn при наложении магнитного поля.

гут распространяться вдоль плоскости плотности тока, скорость к-рых $v = cV/\hbar d$. Эти волны наблюдаются по ступеням на ВАХ [ступени Физе (М. Физе, 1964)] (рис. 3). Если ширина контакта $L > \lambda_J$, то магн. поле проникает в туннельный контакт неоднородно в виде джоулевых вихрей в к-рых магн. поле в к-рых экспоненциально спадает на длине λ_J . Джозефсоновские вихри могут распространяться вдоль контакта под действием тока. На с. с. (из-за малости критич. параметров) сильно влияют флуктуации, к-рые приводят к двум эффектам. Случайные изменения вдоль плоскости контакта джозефсоновской фазы или плотности критич. тока, связанные с локальными неоднородностями туннельного контакта (структурные флуктуации), приводят к искажению Фраунгоферовой зависимости критич. тока от магн. поля. С др. стороны, на контакте может возникнуть разность потенциалов при токе, меньшем критического, связанная со случайным изменением джозефсоновской фазы во времени. Вероятность таких скачков фазы возрастает с увеличением темп-ры, но при низких темп-рах возможно макроскопич. квантовое туннелирование (существует ненулевая вероятность изменения джозефсоновской фазы со временем при $T \rightarrow 0$).

Рассмотренные эффекты могут проявляться во всех слабосвязанных системах. Кроме того, в нек-рых структурах возникают и др. явления. Так, для контактов с прослойкой из нормального металла возможна несинусоидальная зависимость джозефсоновского тока I от ф.

В структурах с непосредств. сверхпроводимостью (рис. 1, б — з), в отличие от обычного туннельного контакта, малость джозефсоновского тока определяется не слабой проницаемостью диэлектрик. барьера (для куперовских пар), а возрастанием плотности тока в области слабой связи (рис. 1, б — з) либо нарушением корреляции электронов в нормальном металле (рис. 1, д, е). В таких структурах наблюдается неравновесная с. с., обусловленная изменением ф-ции распределения электронов по энергиям. Это приводит к возрастанию критич. тока слабосвязанных систем в СВЧ-поле и к избыточному току при больших напряжениях (ВАХ систем отличается от закона Ома, $I = I_{c0} + V/R$, где I_{c0} — избыточный ток, R — сопротивление контакта в нормальном состоянии). В контактах с полупроводниковой прослойкой возможно изменение критич. параметров, связанных с изменением туннельной прозрачности

барьера. На прозрачность барьера сильно влияют концентрации свободных носителей заряда в полупроводнике, к-рую можно изменять как введением примесей, так и с помощью освещения образца. Кроме того, критич. ток I_c может возрастать из-за прохождения куперовских пар по эфлуктуад. каналам — областям с локально пониженным потенц. барьером, а также из-за резонансного туннелирования (резкое возрастание прозрачности барьера при прохождении куперовских пар по цепочкам периодически расположенных локальн. центров).

Разнообразие эффектов позволяет использовать с. с. как для фаз. исследований (определение сверхпроводящей щели по ВАХ одночастотного тока, исследование неоднородности и т.д.), так и для практич. применений (сверхпроводящие преобразователи излучения, сквиды и т.д.).

Лит.: Асламазов Л. Г., Губанов В. Н., Слабая сверхпроводимость. М., 1982; Варона А., Шатерно Д., Эффект Джозефсона: физика и приложения, пер. с англ., М., 1984; Ли и др. в к-бу, Введение в динамику джозефсоновских переходов. М., 1985.

СЛАБАЯ ФОКУСИРОВКА — фокусировка частиц в ускорителе, при к-рой за один оборот частица совершает n с. с. одного бокового (поперечного) колебания. К-тч с. с. относится, напр., фокусировка частиц магн. полем с пост. током.

СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — одно из четырех известных фундам. взаимодействий между элементарными частицами. С. в. значительно слабее сильного и эл.-магн. взаимодействий, но гораздо сильнее гравитационного. В 80-х гг. установлено, что слабое и эл.-магн. взаимодействия — разл. проявления единого электро-слабого взаимодействия.

Об интенсивности взаимодействий можно судить по скорости процессов, к-рые оно вызывает. Обычно сравнивают между собой скорости процессов при энергиях ~ 1 ГэВ, характерных для физики элементарных частиц. При таких энергиях процесс, обусловленный сильным взаимодействием, происходит за время $\sim 10^{-24}$ с, эл.-магн. процесс за время $\sim 10^{-18}$ с, характерное же время процессов, происходящих за счёт с. в. (слабых процессов), гораздо больше: $\sim 10^{-12}$ с, так что в мире элементарных частиц слабые процессы протекают чрезвычайно медленно.

Другая характеристика взаимодействия — длина свободного пробега частицы в веществе. Сильно взаимодействующие частицы (адроны) можно задержать железной плитой толщиной в неск. десятков см, тогда как нейтрино, обладающее лишь с. в., проходило бы, не испытав ни одного столкновения, через железную плиту толщиной порядка миллиарда км. Ещё более слабым является гравитат. взаимодействие, сила к-рого при энергиях ~ 1 ГэВ в 10^{28} раз меньше, чем у с. в. Однако обычно роль гравитат. взаимодействия гораздо заметнее роли с. в. Это связано с тем, что гравитат. взаимодействие, как и электромагнитное, имеет бесконечно большой радиус действия; поэтому, напр., на тела, находящиеся на поверхности Земли, действует гравитат. притяжение всех атомов, из к-рых состоит Земля. Слабое же взаимодействие обладает очень малым радиусом действия: ок. $2 \cdot 10^{-18}$ см (что на три порядка меньше радиуса сильного взаимодействия). Вследствие этого, напр., с. в. между ядрами двух соседних атомов, находящихся на расстоянии 10^{-8} см, ничтожно мало, несравнимо слабее не только электромагнитного, но и гравитат. взаимодействий между ними.

Однако, несмотря на малую величину и короткодействие, с. в. играет очень важную роль в природе. Так, если бы удалось «выключить» с. в., то погасло бы Солнце, поскольку был бы невозможен процесс превращения протона в нейтрон, позитрон и нейтрино, в результате к-рого четыре протона превращаются в ⁴He, два позитрона и два нейтрино. Этот процесс служит осн. источником энергии Солнца и большинства звезд (см. *Водородный цикл*). Процессом с. в. с участием нейтрино вообще исключительно важны в эво-

лучи звезд, т. к. обуславливают потери энергии очень горячими звездами, во взрывах сверхновых звезд с облучением пульсаров и т. д. Если бы не было С. в., были бы стабильны и широко распространены в обычном веществе мюоны, л-мезоны, странные и очарованные частицы, к-рые распадаются в результате С. в. Столь большая роль С. в. связана с тем, что оно не подчиняется ряду запретов, характерных для сильного и эл.-магн. взаимодействий. В частности, С. в. превращает заряженные лептоны в нейтрино, а кварки одного типа (аромата) в кварки др. типов.

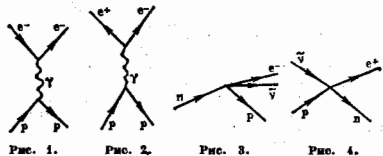
Интенсивность слабых процессов быстро растёт с ростом энергии. Так, бета-распад нейтрона, энерговыделение в к-ром мало (~1 МэВ), длится ок. 10^8 с, что в 10^{13} раз больше, чем время жизни Λ -гиперона, энерговыделение при распаде к-рого составляет ~100 МэВ. Сечение взаимодействия с нуклонами для нейтрино с энергией ~100 ГэВ прибл. в миллион раз больше, чем для нейтрино с энергией ~1 МэВ. По теоретич. представлениям, рост сечения продлится до энергий порядка неск. сотен ГэВ (в системе центра инерции сталкивающихся частиц). При этих энергиях и при больших передачах импульсов проявляются эффекты, связанные с существованием промежуточных векторных бозонов W^{\pm} , Z^0 . На расстояниях между сталкивающимися частицами, много меньших $2 \cdot 10^{-16}$ см (комptonской длины волны промежуточных бозонов), С. в. и эл.-магн. взаимодействия имеют практически одинаковую интенсивность.

Наиб. распространённый процесс, обусловленный С. в. — бета-распад радиоактивных атомных ядер. В 1934 Э. Ферми (E. Fermi) построил теорию β -распада, к-рая с нек-рыми существ. модификациями легла в основу последующей теории т. я. универсального локального четырёхфермионного С. в. (взаимодействия Ферми). Согласно теории Ферми, электрон и нейтрино (точнее, антинейтрино), вылетающие из β -радиоактивного ядра, не находились в нём до этого, а возникли в момент распада. Это явление аналогично испусканию фотонов низкой энергии (видимого света) возбуждёнными атомами или фотонам высокой энергии (γ -квантам) возбуждёнными ядрами. Причиной таких процессов является взаимодействие электрич. зарядов частиц с эл.-магн. полем: движущаяся заряженная частица создаёт электромагнитный ток, к-рый возмущает эл.-магн. поле; в результате взаимодействия частица передаёт энергию квантам этого поля — фотонам. Взаимодействие фотонов с эл.-магн. током описывается выражением $e\vec{j}_{эм}A$. Здесь e — элементарный электрич. заряд, являющийся константой эл.-магн. взаимодействия (см. Константа взаимодействия), A — оператор фотонного поля (т. е. оператор рождения и уничтожения фотона), $\vec{j}_{эм}$ — оператор плотности эл.-магн. тока. (Часто в выражении для эл.-магн. тока включают также множитель e .) В $\vec{j}_{эм}$ дают вклад все заряд. частицы. Напр., слабое, отвечающее электрону, имеет вид: $\vec{j}_e = \psi \nabla \psi - \psi \nabla \psi$ — оператор уничтожения электрона или рождения позитрона, а ψ — оператор рождения электрона или уничтожения позитрона. [Выше для упрощения не показано, что $\vec{j}_{эм}$ так же как A , является четырёхфермионным вектором. Более точно, вместо \vec{j}_e следует писать совокупность четырёх выражений $\vec{j}_e, \vec{j}_e, \vec{j}_e, \vec{j}_e$, где γ_μ — Дирака матрицы, $\mu = 0, 1, 2, 3$. Каждое из этих выражений умножается на соответствующую компоненту четырёхмерного вектора A_μ .]

Взаимодействие $e\vec{j}_eA$ описывает не только испускание и поглощение фотонов электронами и позитронами, но и такие процессы, как рождение фотонами электрон-позитронных пар (см. Рождение пар) или аннигиляция этих пар в фотоны. Обмен фотоном между двумя заряд. частицами приводит к взаимодействию их друг с другом. В результате возникает, напр., рассеяние фотона протонами, к-рое схематически изображается Фейнмана диаграммой, представленной на рис. 1. При переходе

протона в ядре с одного уровня на другой это же взаимодействие может привести к рождению электрон-позитронной пары (рис. 2).

Теория β -распада Ферми по существу аналогична теории эл.-магн. процессов. Ферми положил в основу теории взаимодействие двух «слабых токов» (см. Ток в квантовой теории поля), но взаимодействующих между собой не на расстояниях путём обмена частицей — квантом поля (фотоном) в случае эл.-магн. взаимодействия), а контактно. Это взаимодействие между четырьмя фермионными полями (четырьмя фермионами $\psi, \bar{\psi}, e$ и нейтрино ν) в совр. обозначениях имеет вид: $(G_F/\sqrt{2}) \bar{\psi} \psi$ рн-ев. Здесь G_F — константа Ферми, или константа слабого четырёхфермионного взаимодействия, эксперим. значение к-рой $G_F \approx 10^{-48}$ эрг-см³ (величина $G_F/\hbar c$ имеет размерность квадрата длины, и в единицах $\hbar c = 1$ константа $G_F \approx 10^{-5}/M^2$, где M — масса протона), $\bar{\psi}$ — оператор рождения протона (уничтожения антипротона), ψ — оператор уничтожения нейтрона (рождения антинейтрона), e — оператор рождения электрона (уничтожения позитрона), ν — оператор уничтожения нейтрино (рождения антинейтрино). (Здесь и в дальнейшем операторы рождения и уничтожения частиц



обозначены символами соответствующих частиц, набранными полужирным шрифтом). Ток $\bar{\psi} \psi$, переводящий нейтрон в протон, получил впоследствии название нуклонного, а ток $e \bar{\nu} \nu$ — лептонного. Ферми постулировал, что, подобно эл.-магн. току, слабые токи также являются четырёхмерными векторами: $\vec{j}_p, \vec{j}_n, \vec{j}_e, \vec{j}_\nu$. Поэтому взаимодействие Ферми наз. векторным.

Подобно рождению электрон-позитронной пары (рис. 2), β -распад нейтрона может быть описан похожей диаграммой (рис. 3) [актив. частицы помечены знаком «льда» (\sim) над символами соответствующих частиц]. Взаимодействие лептонного и нуклонного токов должно приводить и к др. процессам, напр. к реакции $\bar{\nu} + \bar{\nu} + p \rightarrow e^+ + \bar{p}$ (рис. 4), к аннигиляции пар $p + \bar{p} \rightarrow e^+ + \nu$ (рис. 5) и $\bar{p} + \bar{p} \rightarrow e^- + \bar{\nu}$ и т. д.

Существ. отличием слабых токов \vec{j}_p и \vec{j}_ν от электромагнитного является то, что слабый ток меняет заряд частиц, в то время как эл.-магн. ток не меняет: слабый ток превращает нейтрон в протон, электрон в нейтрино, а электромагнитный оставляет протон протонами, а электрон электроном. Поэтому слабые токи \vec{j}_p и \vec{j}_ν наз. заряженными токами. Согласно такой терминологии, обычный эл.-магн. ток $e \bar{\nu} \nu$ является *нейтральным током*.

Теория Ферми опирается на результаты исследований в трёх разл. областях: 1) эксперим. исследование собственно С. в. (β -распад), приведшие к гипотезе о существовании нейтрино; 2) эксперим. исследование сильного взаимодействия (ядерные реакции), приведшие к открытию протона и нейтронов и к пониманию того, что ядра состоят из этих частиц; 3) эксперим. и теоретич. исследование эл.-магн. взаимодействия, в результате к-рых был заложен фундамент квантовой теории поля. Дальнейшее развитие физики элементарных частиц неоднократно подтверждало плодотворную взаимозависимость исследований сильного, слабого и эл.-магн. взаимодействий.

Теория универсального четырёхфермионного С. в. отличается от теории Ферми в ряде существенных пунктов. Эти отличия, установленные за последующие годы в результате изучения элементарных частиц, сводятся к следующему.

Слабые токи, к-рые у Ферми были векторными, представляют собой сумму векторного тока V и аксиального тока A . При преобразованиях Лоренца токи V и A ведут себя одинаково, подобно обычным четырёхмерным векторам. Однако при зеркальных отражениях (пространственной инверсии) их поведение различно, т. е. они обладают различной пространственной чётностью P . В результате слабый ток не обладает определённой чётностью. Это его свойство отражает несохранение чётности в С. в. Токи V и A отражаются также зеркальной чётностью C .

Гипотеза о том, что С. в. не сохраняется чётно, была выдвинута Ли Цзундао (Lee Tsung-Dao) и Янг Чженьнином (Yang Chen Ning) в 1956 при теоретич. исследовании распада K -мезонов; вскоре несохранение P - и C -чётностей было обнаружено экспериментально в β -распадах ядер [Бу Чэньшун (Wu Chien-Shung) с сотрудниками], в распаде мюона [Р. Гарви (R. Garwin), Л. Ледерман (L. Lederman), В. Теледжи (V. Telegdi), Дж. Фридман (J. Friedman) и др.] и в распадах др. частиц.

Обобщая огромный эксперим. материал, М. Гелл-Манн (M. Gell-Mann), Р. Фейнман (R. Feynman), Р. Маршак (H. Marshak) и Э. Сударшан (E. Sudarshan) в 1957 предложили теорию универсального С. в. — т. н. $V-A$ теорию. В формулировке, основанной на кварковой структуре адронов, эта теория заключается в том, что полный слабый заряженный ток J_{μ} является суммой лептонных и кварковых токов, причём каждый из этих элементарных токов содержит одну и ту же комбинацию дираковских матриц: $\gamma_{\mu}(1 + \gamma_5)$.

Как выяснилось впоследствии, заряд лептонный ток, представленный в теории Ферми одним членом $e\nu$, является суммой трёх слагаемых:

$$e\nu_e + \bar{\nu}_{\mu} + \bar{\nu}_{\tau},$$

причём каждый из известных заряд. лептонов (электрон, мюон и таежый лептон τ) входит в заряд. ток со своим нейтрино.

Заряд. адронный ток, представленный в теории Ферми членом \bar{p} , является суммой кварковых токов. К 1952 известно пять типов кварков [d , s , b с электрич. зарядом (в единицах e) $Q = -1/3$ и u , c с $Q = +2/3$], из к-рых построены все известные адроны, и предполагается существование шестого кварка (t с $Q = +2/3$). Заряженные кварковые токи, так же как и лептонные токи, обычно записывают в виде суммы трёх слагаемых:

$$\bar{u}d' + \bar{c}s' + \bar{t}b'.$$

Однако здесь d' , s' и b' являются линейными комбинациями операторов d , s , b , так что кварковый заряженный ток состоит из девяти слагаемых. Каждый из токов ($e\nu_e$, $\bar{\nu}_{\mu}$, $\bar{\nu}_{\tau}$, $\bar{u}d'$, $\bar{c}s'$ и $\bar{t}b'$) является суммой векторного и аксиального токов с коэффициентами, равными единице.

Коэффициенты девяти заряженных кварковых токов обычно представляют в виде матрицы 3×3 , к-рая параметризуется тремя углами и фазовым множителем, характеризующим нарушение CP -инвариантности в слабых распадах. Эта матрица получила назв. матрицы Кобаяши — Маскавы (M. Kobayashi, T. Maskawa). Лагранжиан С. в. заряженных токов имеет вид:

$$L_{\text{вт}} = (G_F/\sqrt{2}) j_{\mu}^{\dagger} j^{\mu},$$

где j^{\dagger} — ток, сопряжённый $j_{\mu}(e\nu_e - \bar{\nu}_{\mu}e, \bar{u}d' + \bar{c}s' + \bar{t}b')$ и т. д.). Такие взаимодействия заряженных токов

количественно описывает огромное число слабых процессов: лептонных ($\mu \rightarrow e^{-} + \bar{\nu}_{\mu} + \nu_e$, $\tau \rightarrow e^{-} + \bar{\nu}_{\tau} + \nu_e$, $\nu_e + e^{-} \rightarrow e^{-} + \nu_e$ и т. д.), полулептонных ($p \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_{e}$, $\Lambda \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_{e}$, $K^{+} \rightarrow \pi^{+} + \nu_e$ и т. д.) и нелептонных ($K^{+} \rightarrow \pi^{+} + \pi^{0}$, $\Lambda \rightarrow p + \pi^{-}$, $D^{+} \rightarrow K^{-} + \pi^{+} + \pi^{+}$ и т. д.). Многие из этих процессов были открыты после 1957. За этот период были открыты

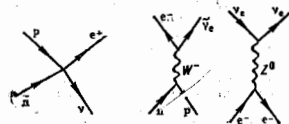


Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

также два принципиально новых явления: нарушение CP -инвариантности и нейтральные токи.

Нарушение CP -инвариантности было обнаружено в 1964 в эксперименте Дж. Кристенсона (J. Christenson), Дж. Кроуина (J. Cronin), В. Фитча (V. Fitch) и Р. Тёрли (R. Turley), к-рые наблюдали распад долгоживущих K^0 -мезонов (K^0) на два π -мезона. Позднее нарушение CP -инвариантности наблюдалось также в полулептонных распадах K^0 . Для выяснения природы CP -инвариантного взаимодействия было бы крайне важным найти к.л. CP -нейтральный процесс в распадах или взаимодействиях др. частиц. В частности, большой интерес представляют поиски дипольного момента нейтрона (наличие к-рого означало бы нарушение инвариантности относительно обращения времени, а следовательно, согласно теореме CPT , и CP -инвариантности).

Существование нейтральных токов было предсказано единой теорией слабого и эл.-магн. взаимодействия, созданной в 60-х гг. Ш. Глоушо (Sh. Glashow), С. Вайнбергом (S. Weinberg), А. Саламом (A. Salam) и др. и позднее получившей назв. стандартной теории электро-слабого взаимодействия. Согласно этой теории, С. в. не является контактным взаимодействием токов, а происходит путём обмена промежуточными векторными бозонами (W^{+} , W^{-} , Z^0) — массивными частицами со спином 1. При этом W^{\pm} -бозоны осуществляют взаимодействия заряж. токов (рис. 6), а Z^0 -бозоны — нейтральных (рис. 7). В стандартной теории три промежуточных бозона и фотон являются квантами векторных, т. н. калибровочных полей, выступающими при асимптотически больших передачах четырёхмерного импульса ($q \gg m_{\nu}$, m_Z , где m_{ν} , m_Z — массы W - и Z -бозонов в энергетич. единицах) совершенно равноправно. Нейтральные токи были обнаружены в 1973 во взаимодействии нейтрино и антинейтрино с нуклонами. Позднее были найдены процессы рассеяния мюонного нейтрино на электроны, а также эффекты несохранения чётности во взаимодействиях электронов с нуклонами, обусловленные электронными нейтральными током $\bar{e}e$ (эти эффекты впервые наблюдались в опытах по несохранению чётности при атомных переходах, проведённых в Новосибирске Л. М. Барковым и М. С. Золоторых, а также в экспериментах по рассеянию электронов на протонах и дейтронах в США).

Взаимодействие нейтральных токов описывается соответствующим членом в лагранжиане С. в.:

$$L_{\text{нт}} = (G_F/\rho\sqrt{2}) j_{\mu}^{\dagger} j^{\mu},$$

где ρ — безразмерный параметр. В стандартной теории $\rho = 1$ (эксперим. значение ρ совпадает с 1 в пределах одного процента эксперим. точности и точности расчёта радиационных поправок). Полный слабый нейтральный ток содержит вклады всех лептонов и всех кварков:

взаимодействия, так и группа $SU(3)$ сильного взаимодействия являются подгруппами единой группы, характеризующейся единой константой малобронового взаимодействия. В ещё более фундам. моделях эти взаимодействия объединяются с гравитационными (т. е. суперобъединение).

Лит.: Ву Ц. С., Мохновский С. А., Бета-распад, пер. с англ., М., 1970; Вайнберг С., Единая теория взаимодействия элементарных частиц, пер. с англ., «УОН», 1976, т. 118, в. 3, с. 505; Тейлор Дж., Каплирование теории слабых взаимодействий, пер. с англ., М., 1978; На пути к единой теории поля. Сб. ст., переводы, М., 1980; Окуни Л. Б., Лептон и кварки, 2 изд., М., 1980. Л. Б. Окуни.

СЛАБЫЙ ГИПЕРЗАРЯД — см. Гиперзаряд.

СЛАБЫЙ ИЗОСПИН — см. Изотопический спин.

СЛАБЫЙ ФЕРРОМАГНЕТИЗМ — существование в антиферромагнетиках спонтанного ферромагн. момента M_0 , величина к-рого мала по сравнению с намагниченностью подрешёток. С. ф. существует у большого числа антиферромагнетиков; наблюдается в природных кристаллах гематита ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) задолго до того, как было открыто явление антиферромагнетизма [1]. Долгое время считалось, что наблюдаемый ферромагнетизм обусловлен примесями других, ферромагн. окислов железа, пока это явление не было обнаружено в химических чистых образцах NiF_2 [2] (см. табл.), MnCO_3 и CoSO_3 [3]. После того были построены термодинамич. теория С. ф. в антиферромагнетиках (И. Е. Дэйлоушский, 1957, [4]).

Вещства со С. ф. обнаруживают характерную магн. анизотропию. СФМ направлено либо вдоль одной выделенной кристаллограф. направления, либо в плоскости, перпендикулярной гл. оси тригональных или гексагональных кристаллов (базисная плоскость). Типичные кривые намагничивания показаны на рис. 1

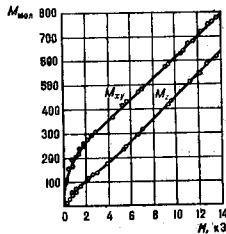


Рис. 1. Зависимость молярной магнитной восприимчивости M_{000} монокристалла MnCO_3 от внешнего поля H , приложенного вдоль тригональной оси Oz (M_{000}^z) и перпендикулярно ей (M_{000}^{xy}) при $T = 4,2\text{K}$.

на примере MnCO_3 . При любом направлении магн. поля H в базисной плоскости xy возникает параллельная ему намагниченность M_{xy} , к-рая зависит от H (начиная с полей ~ 1 кО) по закону:

$$M_{xy} = \sigma_D + \chi_{xy} H, \quad (1)$$

где $\sigma_D = \chi_{xy} H_D$ — величина СФМ, χ_{xy} — магн. восприимчивость в плоскости xy , H_D — эфф. поле Дэйлоушского. Если вектор H направлен перпендикулярно базисной плоскости (вдоль оси Oz), то

$$M_z = \chi_z H. \quad (2)$$

Величина σ_D составляет небольшую долю от намагниченности подрешёток M_n (n — номер подрешётки). Температурная зависимость $\sigma_D(T)$ (рис. 2) аналогична $M_n(T)$, если в веществе при изменении T не происходит перехода на одной антиферромагн. структуры (АС) в другую. Для температурной зависимости $\chi_{xy}(T)$ характерно наличие острого максимума в Неллс точке ($T = T_N$) (рис. 3).

С. ф. возникает в тех антиферромагнетиках, группа магнитной симметрии к-рых допускает одновременно как антиферромагн., так и ферромагн. упорядочение. Найденые все пространств. и точечные группы магн. симметрии, допускающие существование С. ф. [5, 6].

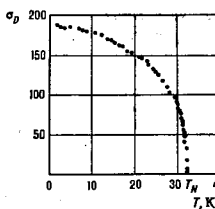


Рис. 2. Температурная зависимость σ_D для CoSO_3 (в единицах СГСМ на моль).

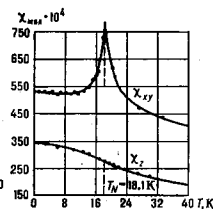


Рис. 3. Температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости для CoSO_3 .

Термодинамическая теория С. ф. основана на разложении термодинамич. потенциала Φ по компонентам векторов антиферромагнетизма L и намагниченности M , являющихся линейными комбинациями M_n (напр., в двухподрешёточном антиферромагнетике $L = M_1 - M_2$, $M = M_1 + M_2$). Это разложение должно быть инвариантным относительно всех преобразований симметрии пространственной группы кристалла. Многие группы допускают в разложении Φ существование членов вида $L_i M_k$ ($i, k = x, y, z$). Их наличие приводит к тому, что при установлении антиферромагн. упорядочения с $L_i \neq 0$ возникает СФМ M_k , величина к-рого может быть рассчитана на ур-нии, получающихся при минимизации Φ . В случае тригональных структур, обладающих пространственной группой D_{3d}^4 ,

$$\Phi = \Phi_0 + (A/2)L^2 + (B/2)M^2 + (a/2)L_z^2 + (b/2)M_z^2 + d(L_x M_y - L_y M_x). \quad (3)$$

Коэффициенты при изотропных членах (A и B), обусловленные обменным взаимодействием, во много раз больше коэффициентов при анизотропных релятивистских членах (a, b, d). Коэф. B является осн. константой обменного взаимодействия, определяющей эффективное обменное магн. поле $H_x = BL/2$. Минимизация (3) при заданном значении L^2 даёт два решения:

- 1) $L \parallel Oz$ ($L_x = L_y = 0$) и $M = 0$ — такой магн. структурой обладает FeCO_3 и низкотемпературная модификация $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$;
- 2) $L \perp Oz$ и $M_x = (d/B)L_y$, $M_y = (d/B)L_x$, $M_z = 0$. При этом возникает СФМ

$$\sigma_D = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = (d/B)L. \quad (4)$$

Этот СФМ мал ввиду малости отношения d/B . Такой магн. структурой обладают MnCO_3 , CoSO_3 , NiCO_3 и высокотемпературная модификация $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$. Если включить в потенциал член с магн. полем, то минимизация Φ приводит к ф-лам (1) и (2), в к-рых $\chi_{xy} = 1/B$, а $\chi_z = 1/(B + b)$.

Вектор σ_D перпендикулярен L . Поэтому в веществе со С. ф. векторы намагниченности подрешёток не направлены строго антипараллельно, а отклоняются на небольшой угол $\varphi = H_x/H_z = 2d/B$ от оси антиферромагнетизма (рис. 4, а). В принципе возможен

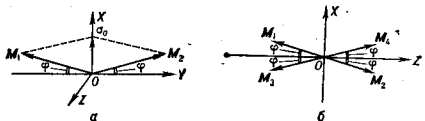


Рис. 4. Образование за счёт сдвига векторов намагниченности подрешёток M_n : а — слабого ферромагнетизма в двухподрешёточном антиферромагнетике; б — антиферромагнитной структуры с четырьмя средними подрешётками.

и продольный С. ф. благодаря различию величин векторов M_n строго антипараллельных подрешёток. Однако во всех известных случаях С. ф. $\sigma_d \perp L$. При перематризации вместе с σ_d должен менять знак и L , т. е. подрешётки должны поворачиваться на 180° .

Слагаемое $d(L_x M_y - L_y M_x)$ из (3) описывает Дзюлошского взаимодействие. Такого вида члены встречаются в ряде пространственных групп тригональных, тетрагональных и гексагональных сингионий. В некр-рых группах тетрагональных сингионий С. ф. описывается членом вида $d(L_x M_y + L_y M_x)$, а в ромбич. сингиониях — членом вида $d(L_x M_x + d_y L_y M_x)$. В моноклиновых сингиониях подобная сумма содержит четыре члена. В большинстве групп гексагональной и кубической сингионий С. ф. описывается членами шестого и четвёртого порядка по $L_i M_k$ [5].

Для антиферромагнетиков с четырьмя и более подрешётками существует векс. векторов L , описывающих разл. антиферромаг. структуры АС. Поэтому в выражение для потенциала Ф могут входить члены типа $L_{12} L_{34}$ (p, q — номера АС), к-рые приводят к возникновению С. ф. со скрещенными подрешётками, не обладающих С. ф. (рис. 4, б).

В микроскопической теории С. ф. рассматривают самый общий вид спинового замалтотона, удовлетворяющий симметрии данного кристалла:

$$\mathcal{H} = \sum_{\alpha, \beta, i, k} S_{\alpha i}^* S_{\beta k} + \sum_{\alpha, i} A_{\alpha i}^* S_{\alpha i}^2 \quad (5)$$

Здесь $S_{\alpha i}$, $S_{\beta k}$ — операторы компонент спинов магн. ионов, расположенных в узлах α и β ; $J_{ik}^{\alpha\beta}$ — тензор, описывающий их взаимодействие; $A_{\alpha i}^*$ — константа одноионной анизотропии. Первый член содержит как обычную изотропную часть ($i = k$), к-рая описывает обменное взаимодействие, так и анизотропную часть ($i \neq k$). Последняя описывает анизотропию, обусловленную межионным взаимодействием, а также С. ф. Ответственная за С. ф. часть гамилтониана может быть представлена в виде $d^{\alpha\beta} [S_{\alpha i} S_{\beta j}]$. Вектор Дзюлошского $d^{\alpha\beta}$ соответствует константе d в разложении (3). В рассмотренных выше тригональных кристаллах $d^{\alpha\beta}$ направлен параллельно оси Oz ($d = d_{zz}$).

Второй член описывает одноионную анизотропию, и обычно коэф. $A_{\alpha i}^*$ не зависит от номера узла. Однако в некр-рых тетрагональных кристаллах ось симметрии в двух эквивалентных узлах элементарной ячейки повернута на 90° и соответственно $A_x^* = -A_y^* = -A_z^*$, $A_z^* = -A_x^*$. В этом случае С. ф. обусловлен не анизотропным обменом, а одноионной анизотропией.

Фазовые переходы. В отличие от обычных антиферромагнетиков, в антиферромагнетиках со С. ф. при $T > T_N$ магн. поле вызывает антиферромаг. упорядочение с вектором L , перпендикулярным приложенному полю. Подобно ферромагнетикам у антиферромагнетиков со С. ф. в магн. поле (параллельном С. ф. моменту) нет различия в магн. симметрии при темп-рах выше и ниже критической [9]. С этим обстоятельством связано возникновение показанного на рис. 3 цикла магн. восприимчивости.

В кристаллах, у к-рых симметрия допускает существование С. ф., наблюдается специфич. *магнитные фазовые переходы*. Во-первых, переходы, обусловленные изменением с темп-рой соотношения констант магн. анизотропии, приводящие к повороту L от одного кристаллографич. направления к другому. В результате такого поворота антиферромагнетик может перейти из состояния со С. ф. в чисто антиферромаг. состояние (переход Морина на $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) или в состояние, где С. ф. сохраняется, но происходит соответствующий поворот вектора СФМ. Подобные *ориентаци-*

онные фазовые переходы в некр-рых ортоферритах и ортохромитах происходит постепенно, и процесс перестройки ограничивает сверху и снизу по темп-ре двумя фазовыми переходами 2-го рода [7]. Во-вторых, наблюдаются фазовые переходы из чисто антиферромаг. состояния со С. ф. под действием магн. поля. Такие переходы происходят в легкосных антиферромагнетиках, если H приложено перпендикулярно лёгкой оси. Магн. поле вызывает поворот вектора L в плоскости, перпендикулярной H , и возникновение СФМ вдоль H . В четырёхпродольных антиферромагнетиках возможен индуцированный магн. полем переход 1-го рода в состояние со С. ф., сопровождающийся перестройкой АС.

В веществах, симметрия к-рых допускает существование С. ф., но анизотропия такова, что вещество переходит в чисто антиферромаг. состояние, в области влияния T_N могут наблюдаться аномалии в температурной зависимости восприимчивости, аналогичные показанной на рис. 3.

Свойства некоторых антиферромагнетиков со слабым ферромагнетизмом

Соединения	Кристаллич. структура	T_N , К	H_E , кОэ	H_D , кОэ	$\Phi = H_D/H_E$
$\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$	тригональная	950	8700	1,9	0,001
NiCO_3	—	25	240	90	0,37
NiF_2	тетрагональная ромбическая	73	280	1,8	0,006
ErFeO_3	—	636	—	—	0,009

Лит.: 1) Smith I. The magnetic properties of hematite, «Phys. Rev.», 8, p. 724 (2) в «J. Geophys. Res.», 3, v. 1, p. 1792; 3) Боровик-Романов А. С., Орлова М. П., Магнитные свойства карбонатов кобальта и никеля, «ЖЭТФ», 1956, в. 31, с. 579; 4) Дзюлошский И. Е., Термодинамическая теория «слабого» ферромагнетизма антиферромагнетиков, «ЖЭТФ», 1957, в. 32, с. 1547; 5) Туров Е. А., Общественные свойства магнитоупорядоченных кристаллов, М., 1963; 6) Витс Р., Symmetry and magnetism, Amst., 1964; 7) Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках, М., 1979; 8) Могила Т., Weak ferromagnetism, in: Magnetism, ed. by G. T. Rado, H. Suhl, v. 1, N. Y., L., 1963; 9) Воротников В. А., С. С. Леонидов по низкоэнергетическому магнетизму, «Новосиб.», 1976.

СЛЕД (шпур) матрицы — сумма элементов гл. диагонали квадратной матрицы. Обозначается $\text{Tr}A$ или $\text{Sp}A$. С. матрицы $A = \|a_{ij}\|$ порядка n есть $\text{Tr}A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Свойства С.: $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}A + \text{Tr}B$, $\text{Tr}(cA) = c\text{Tr}A$, $\text{Tr}A^* = \text{Tr}A$, $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, $\text{Tr}(A \times B) = \text{Tr}A\text{Tr}B$, $\text{Tr}(A^*) = (\text{Tr}A)^*$. С. равна сумме всех собств. значений матрицы A , причём каждое собств. значение считается столько раз, какова его алгебраич. кратность.

СЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ЗАКОН — определяет связь между значениями скорости материальной точки по отношению к разл. системам отсчёта, движущимся друг относительно друга. В анералистической физике, когда рассматриваются скорости, малые по сравнению со скоростью света c , справедлив закон сложения скоростей Галлея:

$$u' = u - v, \quad (1)$$

где u и u' — скорости частицы в двух инерциальных системах отсчёта K и K' соответственно (система K' движется относительно K со скоростью v). Если скорости движения близки к c , то ф-ла (1) неприменима и справедлив С. с. в частной (специальной) относительности теории:

$$u_1' = \frac{u_1 - v}{1 - u_1 v/c^2}, \quad u_1 = \frac{u_1' \sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - u_1' v/c^2}, \quad (2)$$

где $u_1(u_1')$ и $u_1'(u_1)$ — проекции скорости частицы в системе отсчёта $K(K')$ на направления параллельные и

перпендикулярной к \vec{v} . В пределе $|u/c| \ll |v/c| \ll 1$ и $|v/c| \ll |u/c| \ll 1$ ф-лы (2) переходят в (1). В случае, когда скорости u и v параллельны, (2) переписывается в виде

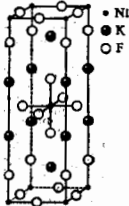
$$u' = \frac{u-v}{1-uv/c^2} \quad (3)$$

Из ф-лы (3), в частности, следует, что если $u = c$, то и $u' = c$ независимо от v , т. е. абс. величина скорости света не зависит от движения системы отсчёта. Тот же вывод справедлив, разумеется, и при произвольном направлении скоростей, когда надо пользоваться ф-лой (2).

В случае неравномерных относит. движений двух систем отсчёта, а также при наличии магнетизма (т. е. в случае общей теории относительности) все приведенные соотношения справедливы в локально отсутствующих инерциальных системах отсчёта K и K' , т. е. в таких бесконечно малых системах отсчёта, к-рые в данный момент и в данном месте неподвижны относительно рассматриваемых систем K и K' соответственно и в к-рых в этот момент нет сил ускорения и нет вращения и деформаций, т. е. они локально инерциальны.

Лит., см. при ст. *Относительности теория*. И. Д. Ноголин.

СЛОЙСТЫЕ МАГНЕТИКИ — кристаллич. вещества, в к-рых обменные взаимодействия внутри слоёв (плоскостей), содержащих магн. ионы, существенно превышают межслойные обменные взаимодействия (энергии взаимодействий соответственно J_E и J'). Малость межслойных взаимодействий обычно выведена отсюда, удаленности магн. плоскостей друг от друга, а также типом магн. упорядочения. Так, в K_2NiF_4 кристаллич. решётка к-рого показана на рис., антиферромагн. обмен внутри плоскости и относительное расположение магн. слоёв приводят к ослаблению межслойного магн. взаимодействия.



Кристаллическая структура соединения K_2NiF_4 .

В простейших моделях С. м. можно рассматривать как систему независимых двумерных (2D)-магнетиков. Различают след. типы внутрислоевого магн. упорядочения: а) гейзенберговский, б) $x-y$, или планарный, в) изинговский (см. *Двумерные решеточные модели*). Их реализация зависит от характера энергии сплюснтой магнитной анизотропии. В случае а) эта энергия пренебрежимо мала, случая б) и в) соответствуют т. н. анизотропии типа «слабая плоскость» и «лёгкая ось». Типичными для случая а) являются вещества, в к-рых магн. подрешетки составлены из ионов Mn^{2+} или Fe^{2+} . По Хунда правилу орбитальный момент обоих ионов $L = 0$, а анизотропия, вызываемая эффектами *интрукристаллического поля*, отсутствует. Тем же эффектом отсутствуют и для магн. ионов Co^{2+} , имеющих спин $S = 1/2$. Единств. источник анизотропии в этих веществах — слабое магн. диполь-дипольное взаимодействие. Типичными для случая б) являются магн. ионы Ni^{2+} и Fe^{2+} , а для случая в) — ионы Co^{2+} .

В 2d-гейзенберговских магнетиках (см. *Гейзенберга модель*) магн. упорядочение отсутствует при отличной от нуля темп-ре [1]. В 2d-планарных магнетиках также отсутствует спонтанная намагниченность, но существует низкотемпературная магн. фаза, характеризующаяся «магнитной жесткостью» [2] и испытывающая фазовый переход Березинского — Костерлица — Таулеса [3] в разупорядоченное состояние (см. *Магнитный фазовый переход*). В 2d-изинговских магнетиках при низких темп-рах спонтанная намагниченность отлична от нуля, т. е. они упорядочены (см. *Изинга модель*).

В случаях а) и б) учёт слабых внеш. (по отношению к внутрислоевоному взаимодействию) полей приводит к сильному нелинейному отклику системы. В качестве таких полей можно рассматривать слабые межслойные взаимодействия [4]. В изинговских магнетиках эти взаимодействия оказываются существенными в малой окрестности ΔT темп-ры T_c фазового перехода [5]:

$$\Delta T \sim T_c (J'/J_c)^{\nu},$$

где критич. флуктуации (см. *Критические явления*) становятся трёхмерными.

Примером изинговского магнетика может служить $CaSb$. Для него характерно ферромагн. изинговское упорядочение в плоскостях с перпендикулярным к плоскостям направлением намагниченности. Слабый обмен между ближайшими и следующими за ближайшими магн. слоями обуславливает сложную периодич. магн. структуру. Фазовая диаграмма температура T — магн. поле H_z для $CaSb$ насчитывает 14 разл. магнитоупорядоченных структур [8], периодичность в H_z достигает 13 периодов решётки (см. *Магнитная атомная структура*).

К слоистым планарным магнетикам относятся $(C_4H_9N_2)_2NiCl_4$ ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10$) [7]. Внутрислоевоое обменное взаимодействие приводит к ферромагн. упорядочению. Благодаря слабой анизотропии этого взаимодействия также магнетикам оказываются планарными. Отношение энергии анизотропии J_a к энергии внутрислоевого обменного взаимодействия J_E составляет по порядку $10^{-4} - 10^{-3}$. Межслойные взаимодействия в несколько раз меньше поля анизотропии ($J' < J_a$) и в соединении $(C_4H_9N_2)_2NiCl_4$ имеют ферромагн. характер, а в остальных соединениях этого типа — антиферромагнитный.

В сравнительно широкой области полей (до 4000 Э) ферромагнетик K_2CuF_4 [8] с кристаллич. структурой, аналогичной K_2NiF_4 (отношение взаимодействий: $J':J_a:J_c \sim 10^{-3}:10^{-3}:1$), ведёт себя как планарный.

Особо следует выделить *интеркалированные соединения*. Процесс интеркалирования графита позволяет приготовить С. м. с хорошо выдержанной периодичностью в расположении магн. ионов и с варьруемым значением межслойного саяза. Впервые в таких соединениях с внедрённым $CoCl_2$ была найдена существенно нелинейная зависимость намагниченности M от магн. поля H [9]: $M \propto \ln H$, что характерно для поведения 2d-гейзенберговских магнетиков.

Лит.: 1) Neel L. N., van der Hoff H., Absence of ferromagnetism or antiferromagnetism in one- or two-dimensional isotropic Heisenberg models, *Phys. Rev. Lett.*, 1966, v. 17, p. 1133; 2) Березинский В. Л., Разрушение дальнего порядка в одномерных и двумерных системах с непрерывной группой симметрии, *ЖЭТФ*, 1970, т. 59, с. 907; 3) Костерлица Ф. М., Thouless D. I., Ordering metastability and phase transition in two-dimensional systems, *J. Phys.*, 1973, v. C6, p. 1181; 4) Покрысовский В. Л., Уайминг Г. В., Магнитные свойства плоских и слоистых систем, *ЖЭТФ*, 1983, т. 65, с. 1499; 5) Onsager L. C., Crystal statistics. I. A two-dimensional model with an order-disorder transition, *Phys. Rev.*, 1944, v. 65, p. 117; 6) Розоват-Мигонди Я. и др., Magnetic properties of cerium plerovites, *J. Magn. & Magn. Mater.*, 1983, v. 31—39, p. 398; 7) De Jongh L. J., van Amstel W. D., Miedema A. R., Magnetic measurements on $(C_4H_9N_2)_2NiCl_4$: ferromagnetic layers coupled by a very weak antiferromagnetic interaction, *Physica*, 1972, v. 58, p. 277; 8) Никитка В. К., Убукович К., Magnetization measurements of two-dimensional planar ferromagnet K_2CuF_4 , *J. Phys. Soc. Japan*, 1981, v. 50, p. 1608; 9) Каримов Ю. С., Исследование нелинейного поведения двумерных ферромагнетиков, *ЖЭТФ*, 1973, т. 65, с. 261.

Г. В. Ушакин.

СЛУХ — способность человека и большинства животных воспринимать продольные звуковые колебания окружающей среды (обычно воздуха или воды). Частотная граница С. со стороны НЧ составляет обычно 10—20 Гц; ВЧ-граница С. сильно различается у разных животных: многие рыбы, земноводные и пресмыкающиеся не воспринимают сигналов частотой выше 1,0—2,0 кГц, в то время как верх. частотная граница С. у летучих мышей превышает 100 кГц, а у дельфинов достигает 200 кГц; приближается к 100 кГц верх. частотная граница С. нек-рых насекомых. У человека

частотный диапазон С. в молодости ограничен 20—25 кГц, с возрастом эта граница постепенно снижается. По сравнению с др. млекопитающими С. человека и высших обезьян отличается сравнительно узким частотным диапазоном; однако у человека очень хорошо развита способность отменять изменения частоты: в диапазоне частот 1,0—2,0 кГц люди с тренированным слухом могут обнаружить различия в неск. Гц, т. е. в десятые доли процента.

Динамик. диапазон С. человека принято считать от абс. порога слышимости (ок. 2·10⁻⁵ Па на частотах 1,0—3,0 кГц) до порога болевое ощущение (ок. 20 Па на тех же частотах). Т. о., мощность сигналов на границах динамич. диапазона различается в 10¹¹ раз, т. е. на 120 дБ. У многих животных динамич. диапазон С. столь же велик. Внутри своего динамич. диапазона С. человек способен заметить изменение амплитуды (звукового давления) всего в неск. процентов; не хуже дифференциальная чувствительность к изменениям амплитуды у мн. животных, напр. у рыб.

С помощью С. определяется направление на источник звука. При этом *бинауральный эффект* позволяет локализовать источник в горизонтальной плоскости с точностью ок. 1°. Для ориентировочной локализации звука по вертикали используются слабые частотные различия приходящих с разных направлений сигналов, что связано с особенностями отражения звука от ушной раковины. Важными качествами слуховых ощущений являются *высота звука*, определяемая с его спектральным составом и периодичностью, и *громкость звука*, сопоставляемая чаще всего с его энергией, интегрируемой за время 50—150 мс.

Наиб. удивительным свойством С., связанным с функционированием целостного мозга, является способность к практически мгновенной классификации сложных звуков по трудно формализуемым признакам, таким, напр., как интонация речи, особенности произношения определенных диктором и т. д. Способность к такому анализу звуковых сигналов С. сохраняет и в условиях *маскировки звука*, когда полезный сигнал сопровождается звуковыми помехами. Слуховую систему можно условно разделить на периферическую и центральную. Периферич. часть включает наружное, среднее и внутреннее ухо. Два первых отдела служат для концентрации звуковой энергии, осуществления акустико-механич. преобразования и передачи механич. колебаний в жидкую среду внутр. уха. В специализиров. слуховых отделах внутр. уха происходит частотный анализ механич. колебаний, их преобразование в аналоговые электрич. потенциалы рецепторных волосковых клеток, а затем — в импульсную активность волокон слухового нерва. Частотный анализ в слуховом отделе внутр. уха млекопитающих, нап. улиткой, осуществляется на эластичной базилярной мембране с непрерывно меняющейся по длине упругостью и массой. Добротность анализатора резко усиливается вследствие существования активных механизмов положитель. обратной связи, обусловленных, по-видимому, вторичными электромеханич. преобразованием сигнала наружными волосковыми клетками, способными к изменению своей конфигурации. В отличие от наружных, внутр. волосковые клетки выполняют истинно рецепторные ф-ции, осуществляя только механоэлектрич. преобразование сигнала и выделение неизвестного ещё вещества — переносчика, приводящего к возбуждению волокон слухового нерва. Со слухового нерва начинается центр. часть слуховой системы, где вся информация о звуке представляется в виде частотно-импульсного кода нейронной импульсации. Отделы головного мозга, производящие обработку звукового сигнала, составляют т. н. слуховой путь, состоящий у млекопитающих из последовательно расположенных групп ядер: колликулярные ядра, ядра верх. оливок, ядра боковой петли, ядра задних холмов, медиальная колленчатое тело, слуховые зоны коры головного мозга.

Нейроны каждого из этих отделов или уровней слухового пути обеспечивают описание звукового сигнала по набору признаков: спектральным особенностям, особенностям временных изменений, наличием модуляции, наличием задержанных копий (эхо) и т. д. Эта обработка сигнала обеспечивает др. отделы головного мозга необходимой информацией для осуществления классификации звука, формирования слухового ощущения и принятия решения об ответной реакции организма. Процессы обработки сигналов в слуховом нейронном пути специфичны у разных видов животных.

При изучении С. используются методы психологии, и *физиологической акустики*. Методы первой из этих дисциплин применяются гл. обр. по отношению к человеку и позволяют определять психообразные слуховые пороги, а также оценивать и сравнивать такие качества слуховых ощущений, как высота и громкость. При работе с животными используют поведенческие методы, основанные обычно на условных рефлексах и также позволяющие оценивать как абсолютные, так и дифференциальные пороги С.

Физиология, акустика, изучающая последовательные этапы преобразования звукового сигнала на разных уровнях слуховой системы, пользуется разнообразными методами. Так, колебания базилярной мембраны исследуют, используя *Мессбауэра эффект* или лазерную интерферометрию; при анализе характеристик импульсной активности одиночных нейронов широко применяют физ. и матем. методы анализа случайных процессов.

Особое место в исследовании С. занимают методы матем. и физ. моделирования. Широко используются моделирование периферич. слуховой обработки, прежде всего фильтрации сигнала в улитке внутр. уха. Исследования С. имеют важное практич. значение для диагностики и лечения нарушений С., к-рым страдает, по ориентировочной оценке, 4—6% взрослого населения планеты. Второе важное практич. применение работ по изучению С. — разработка на бионической основе систем анализа и классификации сложных звуковых сигналов, прежде всего речи.

Лит.: Гельфанд С. С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику, пер. с англ., М., 1984; Вибингов Н. Г. Описание признаков звука нейронами слуховой системы наземных позвоночных, М., 1987; И. Г. Выблике, СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА — одно из осн. понятий теории вероятностей; величина, значения к-рой зависят от случая, причём определены вероятности всех её значений. Примерами являются число выпавшей решки при 10-кратном случайном бросании монеты или расстояние, на к-рое случайно движущаяся броуновская частица отошла от своего начального положения за время t.

В *вероятностной теории* для описания случайного явления принята след. схема: вводится подходящее «вероятностное» пространство (пространство элементарных событий) Ω — множество всех «мыслимых» случаев — реализаций этого явления, и каждому подмножеству $A \subset \Omega$ этих случаев (событию) приписывается неотрицательное число $P(A)$ — *вероятность* события A. Так, в случае 10 независимых бросаний монеты вероятностное пространство состоит из 2¹⁰ последовательностей $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_{10})$, где каждое ω_i — герб или решка (исход i-го бросания монеты), $i = 1, \dots, 10$; вероятность каждого события $A = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$, состоящего из N раз. последовательностей $\omega_k, P(A) = N \cdot 2^{-10}$. Вероятностное пространство, описывающее броуновское движение частицы, состоит из всех мыслимых траекторий этого движения; правило, по к-рому вводится вероятности событий $P(A)$ из этого пространства, довольно сложно (см., напр., [3]).

Теперь можно более точно определить С. в $\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$) как числовую ф-цию на вероятностном пространстве Ω . В наиб. простом случае, когда ξ принимает лишь дискретное множество (конечное или счётное) значений x_1, \dots, x_n , набор вероятностей

$$p_k = P(\omega: \xi(\omega) = x_k), \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

наз. распределением вероятностей значений C . в ξ (или, короче, распределением ξ). В случае, когда принимаем значения из произвольного «непрерывного» числового множества (так, что вероятность каждого отдель. значения $\xi(\omega)$, как правило, равна нулю), распределение ξ задается с помощью т. н. ф. функции распределения

$$F_{\xi}(x) = P\{\omega: \xi(\omega) \leq x\}, \quad -\infty < x < \infty.$$

При этом в случае дискретного множества значений

$$F_{\xi}(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k.$$

Если рассматривается одновременно неск. С. в. ξ_1, \dots, ξ_n (напр., число всех репек в последовательности $\omega = (\alpha_1, \dots, \alpha_{10})$ и число двух последовательных выпадений решки, три координаты $x(t), y(t), z(t)$ броуновской частицы в момент времени t), то вводят их совместную ф-цию распределения

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{\omega: \xi_1(\omega) \leq x_1, \dots, \xi_n(\omega) \leq x_n\}.$$

С. в. ξ_1, \dots, ξ_n наз. независимыми, когда эта ф-ция распадается на произведение вероятностей отд. С. в.

Ср. значение (матем. ожидание) $\langle \xi \rangle$ С. в., принимающей значения из дискретного множества чисел x_1, \dots, x_n , определяется ф-лой

$$\langle \xi \rangle = \sum_k x_k p_k.$$

В общем случае, когда С. в. принимает «непрерывное» множество значений, полагают

$$\langle \xi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_{\xi}(x),$$

где $\int \cdot dF_{\xi}(x)$ — т. н. интеграл Стильтьеса (см. [1]). Дисперсия $D\xi$ С. в. определяется как

$$D\xi = \langle (\xi - \langle \xi \rangle)^2 \rangle.$$

Осн. рабочий (неформальный) принцип теории вероятностей состоит в том, что все сведения о статистич. свойствах С. в. можно целиком извлечь из её ф-ции распределения (а в случае неск. С. в. — из их совместной ф-ции распределения), не обращаясь к деталям явной зависимости $\xi(\omega)$ от случая $\omega \in \Omega$.

Лит.: 1) Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, 6 изд., М., 1988; 2) Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т. 1, пер. с англ., [3 изд.], М., 1984; 3) Глиман И. И., Скороход А. В., Введение в теорию случайных процессов, 2 изд., М., 1977.

СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ на множестве T — семейство случайных величин $\{\xi_t, t \in T\}$, помеченных элементами множества T (наз. областью определения С. ф.) и заданных на одном и том же вероятностном пространстве Ω : $\xi_t = \xi_t(\omega) \in \Omega$. Напр., при л-кратном бросании монеты, когда пространство Ω состоит из 2^n последовательностей $\omega = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, где $\alpha_k = 0$ или 1 [выпадение решки (0) или герба (1) при k -м бросании], можно ввести С. ф. $\{\xi_k, k = 1, \dots, n\}$ с областью определения $T = \{1, 2, \dots, n\}$, где $\xi_k = \alpha_k - k$ — координата в последовательности ω , при броуновском движении частицы в течение промежутка времени $T = [0, t_0]$, когда пространство Ω образовано всеми возможными её траекториями

$$\omega = \{r(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in R^3, 0 \leq t \leq t_0\},$$

в качестве С. ф. можно выбрать семейство $\{\xi_t^i, t \in T\}$ значений абсцисс $x(t)$ точек $r(t)$ во все моменты времени t : $\xi_t^i(\omega) = x(t)$.

В случаях, когда область определения T совпадает с числовой осью (или отрезком числовой оси), множест-

вом целых чисел, многомерным пространством Ω ($v > 1$) или областью в нём, С. ф. называют соответственно *случайным процессом*, случайной *или* *последовательностью* (или *временными рядами*), *случайным полем*. Числовую ф-цию $\{\xi(t), t \in T\}$ на множестве T , получающуюся при фиксировании к.-л. случая $\omega = \omega_0 \in \Omega$: $\xi(t) = \xi(t, \omega_0)$, называют реализацией С. ф. (или её *выборочной функцией*).

Для любого конечного набора элементов $t_1, \dots, t_n \in T$ определена совместная ф-ция распределения вероятностей значений набора случайных величин $\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n}$:

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{\omega: \xi_{t_1}(\omega) \leq x_1, \dots, \xi_{t_n}(\omega) \leq x_n\}.$$

Совокупность всех таких ф-ций $\{F_{t_1, \dots, t_n}\}$ для всевозможных наборов $(t_1, \dots, t_n \in T, n = 1, 2, \dots)$ элементов на T наз. семейством конечных мерных распределений С. ф. $\{\xi_t, t \in T\}$. Считается, что вся информация о стохастич. свойствах С. ф. целиком заключена в семействе её конечномерных распределений, т. е. две реал. С. ф. $\{\xi_t^1, t \in T\}$ и $\{\xi_t^2, t \in T\}$ (заданные на одном и том же или на разных вероятностных пространствах), у к-рых семейства конечномерных распределений совпадают для всех наборов (t_1, \dots, t_n) и значений (x_1, \dots, x_n) , с вероятностной точки зрения эквивалентны.

Лит.: Глиман И. И., Скороход А. В., Введение в теорию случайных процессов, 2 изд., М., 1977. Р. А. Мильос. **СЛУЧАЙНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ** — вырождение, не связанное со свойствами симметрии квантовой системы и получающееся вследствие совпадения значений энергии для двух различных её квантовых состояний. Так, для сложных атомов могут случайно совпадать энергии уровней, принадлежащих разл. последовательностям алектронных уровней энергии. Для колеб. состояний молекул возможны совпадения удвоенной частоты собств. колебаний с частотой др. собств. колебаний, что приводит к С. в. колеб. уровней.

Лит. см. при ст. *Вырождение*. **СЛУЧАЙНОЕ ПОЛЕ** — случайная ф-ция $\xi(Q)$ неск. непрерывных переменных (параметров) $Q = (\alpha, \beta, \gamma, \dots)$, т. е. такая ф-ция, реализации к-рой подчиняются вероятностным законам, задающим значение ф-ции в каждой точке пространства и взаимосвязь значений в соседних точках. Число независимых переменных фиксирует размерность пространства, на к-ром задано С. п. Если одним из параметров является время t , то говорят о переменном С. п. в пространстве, размерность к-рого определяется числом остальных параметров. Напр., $\xi(Q) = \xi(t, r)$ — переменное С. п. в трёхмерном пространстве (x, y, z) , наз. также пространственно-временным С. п. Такие С. п. чаще всего встречаются в физике.

С. п. используют при вероятностном описании флуктуаций, являющихся в системах с распределенными параметрами, в частности при описании флуктуирующей плотности, темп-ры, диэлектрич. проницаемости и др. параметров разл. сред, при исследовании флуктуирующей ал-мага. и звуковых волн, распространяющихся в случайно-неоднородных средах, в задачах пространственно-временного прѐдма и обработки сигналов на фоне шумов и помех, при описании полей шумов и помех разл. происхождения, при вероятностной трактовке нек-рых результатов квантовой теории и т. д.

С. п., описываемое N ф-циями $\xi^{(i)}(Q), i = 1, 2, \dots, N$, наз. N -мерным. Компоненты $\xi^{(i)}(Q)$ в общем случае имеют разл. физ. природу (напр., совокупности давления, плотности и трёх компонент скорости), особый интерес представляет случай, когда величины $\xi^{(i)}(Q)$ имеют одинаковую размерность и преобразуются как компоненты вектора (тензора) при преобразовании системы координат. В этом случае говорят о векторном (тензорном) С. п.

Основные понятия. Для С. п. используют те же способы задания и статистич. описания, что и для *случай-*

мы процесс, нужно только вместо одной переменной t всюду подражать совокупности параметров Q . В частности, на С. п. обобщается n -точечная плотность вероятности

$$w_n(\xi_1, Q_1; \dots; \xi_n, Q_n) d\xi_1 \dots d\xi_n = P(\xi_1 \leq \xi(Q_1) \leq \xi_1 + d\xi_1, \dots, \xi_n \leq \xi(Q_n) \leq \xi_n + d\xi_n, v=1, \dots, n),$$

к-рая должна удовлетворять условиям неотрицательности, согласованности и нормировки, а также связанная с ней преобразованием Фурье n -мерная характеристическая функция

$$\Phi_n(v_1, \dots, v_n, Q_1, \dots, Q_n) = \left\langle \exp\left(i \sum_{j=1}^n v_j \xi_j\right) \right\rangle = \int \dots \int w_n(\xi_1, Q_1; \dots; \xi_n, Q_n) \exp\left(i \sum_{j=1}^n \xi_j v_j\right) d\xi_1 \dots d\xi_n.$$

В теории С. п. используют функциональные методы, при этом вводят функционалы плотности вероятности, являющийся каноническим обобщением w_n , либо характеристич. функционал

$$\Phi[v] = \left\langle \exp\left(i \int \xi(Q)v(Q)dQ\right) \right\rangle.$$

Моментные (M) и кумулянтные (K) функции выражаются через характеристич. функционал при помощи функциональных (вариационных) производных:

$$M_n(Q_1, \dots, Q_n) = i^{-n} \frac{\delta^n \Phi[v]}{\delta v(Q_1) \dots \delta v(Q_n)} \Big|_{v=0},$$

$$K_n(Q_1, \dots, Q_n) = i^{-n} \frac{\delta^n \ln \Phi[v]}{\delta v(Q_1) \dots \delta v(Q_n)} \Big|_{v=0}.$$

При статистич. описании С. п. необходимо учитывать причинно-следственные связи поля на оси времени и его возможные специфич. свойства, такие, как однородность и изотропность, на разл. гиперповерхностях Q -пространства.

С. п. наз. статистически однородным в узком смысле, если все его статистич. характеристики не изменяются при преобразовании трансляции $Q \rightarrow Q + \delta Q$. Если указанным свойством обладают только ср. значение и корреляц. ф-ция, то говорят о статистич. однородности в широком смысле. Многомерные С. п., обладающие таким свойством, наз. однородными и однородно связанными.

Понятие статистич. однородности С. п. является обобщением понятия стационарности случ. процесса. Если речь идёт о пространственно-временных С. п., то различают стационарность поля по времени и его однородность по пространству. координатам, при этом С. п. может быть статистически однородным по части координат и неоднородным — по остальным. Иногда С. п. однородны только на нек-рых поверхностях (на плоскости, на сфере и т. п.). Статистич. однородность может иметь место по пространственно-временному аргументу, напр. по аргументу $r - vt$ в случае т. н. «замороженных» неоднородностей, движущихся как целое равномерно со скоростью v и описываемых С. п. $\xi(r - vt)$.

При статистич. описании С. п. часто ограничиваются корреляционной теорией, в к-рой используют только моменты 1-го и 2-го порядка, т. е. ср. значение

$$\langle \xi(Q) \rangle = \int \xi w_1(\xi, Q) d\xi,$$

и корреляц. ф-цию

$$\psi(Q_1, Q_2) = \langle \xi(Q_1) \xi(Q_2) \rangle = \int \int \xi_1 \xi_2 w_2(\xi_1, Q_1; \xi_2, Q_2) d\xi_1 d\xi_2,$$

$$\xi_i = \xi_j - \langle \xi_i \rangle.$$

Характерный масштаб убывания корреляц. ф-ции наз. масштабом или радиусом корреляции. Напр., С. п. с гауссовой корреляц. ф-цией

$$\psi(r) = \sigma^2 \exp(-x^2/a^2 - (y^2 + z^2)/b^2)$$

имеет масштаб корреляции a вдоль оси x и радиус корреляции b в плоскости (y, z) . Корреляц. ф-ция точно описывает только поля с нормальными (гауссовыми) законом распределения вероятностей.

Многомерное С. п. $\xi^{(n)}(Q)$ в рамках корреляц. теории характеризуется совокупностью ср. значений $\langle \xi^{(n)}(Q) \rangle$ и корреляц. матрицей $\Psi_{jk}(Q_1, Q_2) = \langle \xi^{(n)}(Q_1) \xi^{(n)}(Q_2) \rangle$, в к-рой диагональные элементы представляют собой ф-ции автокорреляции, а недиагональные — ф-ции взаимной корреляции компонент $\xi^{(n)}$ и $\xi^{(k)}$.

В приложениях приходится иметь дело с комплексными и С. п. $\xi(Q) = \eta(Q) + i\zeta(Q)$, полное статистич. описание к-рых не отличается от описания двумерного С. п. с компонентами $\eta(Q), \zeta(Q)$. Обычно не производят разделения С. п. на вещественную и мнимую части, а оперируют непосредственно с $\xi(Q)$ и комплексно сопряжённым полем $\xi^*(Q)$. При описании таких С. п. в рамках корреляц. теории приходится поэтому рассматривать две корреляц. ф-ции

$$\psi(Q_1, Q_2) = \langle \xi(Q_1) \xi^*(Q_2) \rangle = \langle \xi(Q_1) \xi^*(Q_2) \rangle - \langle \xi(Q_1) \rangle \langle \xi^*(Q_2) \rangle,$$

$$\tilde{\psi}(Q_1, Q_2) = \langle \xi(Q_1) \xi(Q_2) \rangle = \langle \xi(Q_1) \xi(Q_2) \rangle - \langle \xi(Q_1) \rangle \langle \xi(Q_2) \rangle.$$

через к-рые выражаются ф-ции корреляции вещественной и мнимой частей комплексного С. п.:

$$\psi_r(Q_1, Q_2) = (1/2) \operatorname{Re} [\psi(Q_1, Q_2) + \tilde{\psi}(Q_1, Q_2)],$$

$$\psi_i(Q_1, Q_2) = (1/2) \operatorname{Re} [\psi(Q_1, Q_2) - \tilde{\psi}(Q_1, Q_2)],$$

$$\tilde{\psi}_r(Q_1, Q_2) = (1/2) \operatorname{Im} [\tilde{\psi}(Q_1, Q_2) - \psi(Q_1, Q_2)],$$

$$\tilde{\psi}_i(Q_1, Q_2) = (1/2) \operatorname{Im} [\tilde{\psi}(Q_1, Q_2) + \psi(Q_1, Q_2)].$$

Для случайного эл.-магн. поля с напряжённостью элентрич. поля $E(r)$ вводят поля релаксации ψ и $\tilde{\psi}$ матрицу $P_{jk}(r) = \langle E^{(j)}(r) E^{(k)}(r) \rangle$. С её помощью вычисляются Стокса параметры, характеризующие состояние поляризации С. п.

Простейшей мерой статистич. связи значений С. п. в разных точках Q -пространства являются коэффициенты корреляции:

$$K_{ii}(Q_1, Q_2) = \frac{\psi_{ii}(Q_1, Q_2)}{[\psi_{ii}(Q_1, Q_1)\psi_{ii}(Q_2, Q_2)]^{1/2}},$$

$$K_{jk}(Q_1, Q_2) = \frac{\psi_{jk}(Q_1, Q_2)}{[\psi_{ii}(Q_1, Q_1)\psi_{kk}(Q_2, Q_2)]^{1/2}}.$$

Пространственно-однородные поля, у к-рых $\psi(r)$ и $\tilde{\psi}(r)$ зависят только от модуля вектора $r = r_1 - r_2$, т. е. $\psi(r_1, r_2) = \psi(r)$, $\tilde{\psi}(r_1, r_2) = \tilde{\psi}(r)$, наз. статистически изотропными в широком смысле. (Изотропность в узком смысле подразумевает аналогичные свойства непосредственно у плотностей вероятности.) Многомерные С. п., у к-рых указанным свойством обладают ф-ции корреляции, являются изотропными и изотропно связанными. Как и однородность, изотропность полей может иметь место лишь на нек-рых гиперповерхностях пространства независимых переменных.

Для статистически однородных (в широком смысле) С. п. справедливо обобщение Винера — Хинчина теоремы, устанавливающее взаимосвязь между корреляц. ф-цией и пространственно-временной спектральной плотностью $G(\omega, k)$. Для поля, стационарного по времени и однородного в трёхмерном пространстве, эта связь имеет вид:

$$\psi(t, r) = \int_{-\infty}^{\infty} \int G(\omega, k) \exp[i(kr - \omega t)] d\omega dk,$$

$$G(\omega, k) = (2\pi)^{-4} \int \psi(t, r) \exp[i(kr - \omega t)] dt dr.$$

Через пространственно-временную спектральную плотность $G(\omega, k)$ выражаются пространственный $\Phi(k)$ и временной (частотный) $g(\omega)$ спектры С. п.:

$$\Phi(k) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega, k) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(0, r) \exp(-ikr) dr,$$

$$g(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega, k) dk = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(\omega, 0) \exp(i\omega t) dt.$$

Для многомерных однородных и однородно связанных С. п. аналогичная связь имеется между элементами корреляц. матрицы $\Psi_{ij}(t, r)$ и соответствующими элементами матрицы спектральной плотности $G_{ij}(\omega, k)$. Ввиду положит. определенности матриц Ψ_{ij} диагональные элементы матрицы G_{ij} вещественны и неотрицательны, а недиагональные элементы могут быть комплексными.

Пространственным аналогом случайного процесса со стационарными приращениями является лок к а л ь н о о д н о р о д н о е С. п., для к-рого разность ср. значений $\langle \xi(r_1) \rangle - \langle \xi(r_2) \rangle$ и структурная ф-ция

$$D_{\xi}(r_1, r_2) = (\xi(r_1) - \xi(r_2))^2$$

зависит только от разности $r = r_1 - r_2$. Если эти величины зависят только от модуля r , говорят о локально изотропном С. п. Локально однородные и локально изотропные С. п. используют, напр., при описании флуктуаций параметров турбулентных сред.

В рамках корреляц. теории локально однородные С. п. можно также описывать при помощи спектральной плотности $\Phi(k)$. Из-за расходимости интеграла

$\int_{-\infty}^{\infty} \Phi(k) \exp(ikr) dk$ при $k \rightarrow 0$ корреляц. ф-ция для таких С. п. не существуют, а структурная ф-ция существует, т. к. интеграл $D(r) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(k) [1 - \cos kr] dk$ сходится при

меньше жестких требованиях. Это следствие «вечности» структурной ф-ции к флуктуациям, пространственные масштабы к-рых превышают рассматриваемое расстояние $r = |r_1 - r_2|$.

Аналогом квазистационарных процессов являются к в а з и о д н о р о д н ы е С. п., у к-рых многоточечные статистик. характеристики слабо зависят от координат центра тяжести рассматриваемых точек r_1, r_2, \dots, r_n по сравнению с зависимостью от взаимного расположения этих точек, т. е. от разностей $r_j - r_k$. Для таких С. п. вводит понятие локальной спектральной плотности, равной преобразованию Фурье пространственной корреляц. ф-ции по разностям переменным $r = r_1 - r_2$.

Марковские случайные поля. В физ. задачах часто рассматривают С. п., заданные при помощи *стохастических уравнений*, т. е. динамич. ур-ний, содержащих случайные сторонние воздействия. Вид динамич. ур-ний определяется физ. закономерностями, а в качестве сторонних воздействий, описывающих источники случайных возмущений, часто используют С. п., дельта-коррелированные по тем или иным переменным. Исследуемое С. п. при этом является м а р к о в с к и м по указанным переменным, что упрощает вычисление его статистич. характеристик.

Важным примером таких С. п. является поля равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике, описываемые *Максвелла уравнениями* с дельта-коррелированными сторонними токами $i_e(r)$ и $j_m(r)$:

$$\text{rot } H = ik\hat{e}E + 4\pi c^{-1}j_e, \quad \text{rot } E = -ik\hat{h}H - 4\pi c^{-1}j_m,$$

где $k = \omega/c$ — волновое число, \hat{e} и \hat{h} — комплексные тензоры диэлектрич. и магн. проницаемости среды с компонентами $\epsilon_{\alpha\beta} = \epsilon' + i4\pi\omega^{-1}\sigma_{\alpha\beta}$, $\mu_{\alpha\beta} = \mu_{\alpha\beta} - i4\pi\omega^{-1}\tau_{\alpha\beta}$. Элементы корреляц. матрицы вектор-

ных полей i_e и j_m зависят от электрич. и магн. проводимостей среды $\sigma_{\alpha\beta}$ и $\tau_{\alpha\beta}$ и в соответствии с *флуктуационно-диссипативной теоремой* описываются выражениями:

$$\langle j_m(r_1) |_{r_1}^* |_{r_2} \rangle = \theta(\omega, T) \pi^{-1} \sigma_{\alpha\beta} \delta(r_1 - r_2),$$

$$\langle j_m(r_1) |_{m_1}^* |_{m_2} \rangle = \theta(\omega, T) \pi^{-1} \tau_{\alpha\beta} \delta(r_1 - r_2),$$

$$\langle j_e(r_1) |_{m_1}^* |_{m_2} \rangle = 0,$$

где $\theta(\omega, T) = (\hbar\omega/2) \text{cth}(\hbar\omega/2kT)$ — ср. энергия квантового осциллятора с собств. частотой ω при темп-ре T , к-рая в классич. области $\hbar\omega \ll kT$ переходит в $\theta(\omega, T) = kT$.

К С. п. такого типа приводит также т. н. *марковского процесса приближение* в теории распространения волн в случайно-неоднородных средах. В этом приближении волновые поде описываются параболич. ур-нием, в к-ром флуктуац. часть диэлектрич. проницаемости среды полагают дельта-коррелированной в направлении распространения падающей волны (см. *Параболического уравнения приближение*).

Понятие «марковского С. п. тесно связано с причинностью, под к-рой понимают функциональную зависимость С. п. в данной пространственно-временной точке от предшествующих значений поля по временной или пространственной координате. В общем случае не всегда удается выделить в пространстве координату или совокупность координат, но к-рым исследуемое С. п. можно было бы считать марковским. Эта трудность не возникает, если речь идет о марковских С. п. по времени. Такие С. п. используют в неравновесной термодинамике, в статистич. гидромеханике, а также в теории оптимальной пространственно-временной обработки случайных сигналов на фоне шумов и помех. Примером С. п. такого типа является поле $\xi(t, r)$, удовлетворяющее стохастич. ур-нию

$$d\xi(t, r)/dt + f(t, r, \xi) = \chi(t, r)$$

с аддитивными сторонним воздействием $\chi(t, r)$, обладающим корреляц. ф-цией

$$\langle \chi(t_1, r_1) \chi(t_2, r_2) \rangle = \kappa(t_1, r_1, t_2) \delta(t_1 - t_2).$$

Если распределение $\chi(t, r)$ гауссово, то для функционала плотности вероятности этого С. п. справедливо обобщение *Фоккера — Планка уравнение*

$$\frac{\partial v(t, \xi)}{\partial t} = \int_D \frac{\partial}{\partial \xi(r)} \{ f(t, r, \xi) v(t, \xi) \} dr +$$

$$+ \frac{1}{2} \int_D \int_D \chi(t, r_1, r_2) \frac{\partial^2 v(t, \xi)}{\partial \xi(r_1) \partial \xi(r_2)} dr_1 dr_2,$$

в к-ром вместо частных производных фигурируют функциональные производные и, кроме того, интегрирование по r проводится в пределах той области пространства D , на к-рой задано С. п.

При нач. условии $v(t_0, \xi) = \delta(\xi(r) - \xi_0(r))$ это ур-ние описывает функционал плотности вероятности перехода С. п. из начального (в момент t_0) состояния $\xi_0(r)$ в состояние $\xi(r)$ в текущий момент t . Описанное ур-ние (как и вообще подобные ур-ния для функционалов плотности вероятности) имеет символич. смысл, поскольку нормировочные константы величин $v(t, \xi)$ обычно обращаются в 0 или в ∞ . С матем. точки зрения было бы корректно было бы оперировать с характеристич. функционалами, свободными от этого недостатка. Однако в физ. приложениях представляются интерес такие статистич. характеристики С. п., к-рые не зависят от нормировочных констант: моментные и кумулянтные ф-ции, отношение функционалов плотности вероятности (т. е. отношение правдоподобия) и др. Для

вычисления этих величин можно использовать обобщённое ур-ние Фокера — Планка. К более сложным ур-ниям для функционала плотности вероятности полей приводит учёт негауссовых сторонних воздействий (при сохранении их дельта-коррелированности по времени), неадиабатичность этих воздействий в стохастич. ур-ниях и многомерность рассматриваемого С. в.

Лит.: М о н и н А. С., Я г л о в А. М. Статистическая гидродинамика, ч. 1—2, М., 1965—67; Х о л о в Р. В., М а р о в Ю. Н., О марковских волновых процессах, в сб.: *Проблемы математической физики и вычислительной математики*, М., 1977; Введение в статистическую радиофизику, ч. 2 — Р а з л и чия в С. М., К р а в ч о Ю. А., Т а т а р с к и й В. И., С л у ч а й н ы е поля, М., 1978; К л я к и н В. И., *Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах*, М., 1980; Р о з а в о в Ю. А., *Волновые случайные поля*, М., 1981; А х м а т о в С. А., Д а в я н о в Ю. Е., Ч и р к и н А. С., Введение в статистическую радиофизику в оптику, М., 1981.

Ю. А. Крайнов, А. В. Шмелев.

СЛУЧАЙНЫЕ ВОЛНЫ — случайные поля волновой природы (акустич., эл.-магн., уругие, концентрационные и др.). С. в. могут возникать по мн. причинам. Волновые задачи классич. физики описываются дифференциальными (или интегродифференциальными) ур-ниями вида $\hat{L}u = q$, где u — волновое поле, k -рое может быть скалярным или векторным, \hat{L} — волновой оператор (в общем случае — нелинейный), а q — функция q задаёт источник волн. В таких задачах набр. распространёнными причинами случайности являются: 1) источники поля (задана статистика источников q ; в области, свободной от источников, должна быть задана статистика «виртуальных» источников, т. е. статистика граничных значений поля); 2) свойства среды (задана статистика среды), т. е. статистич. характеристики оператора \hat{L} ; 3) форма и положение границ раздела (должна быть задана статистика границ); 4) условия прёвма и регистрации волн (подразумевается задание «статистики прёвмика» и «статистики помера»); 5) нелинейность волнового ур-ния, когда даже в отсутствие внеш. источников случайности поведение волн может быть «кваислучайными» или «стохастичными» за счёт возникновения динамического стохастич. режима. К этим статистич. схемам сводится постановка большинства задач теории С. в. Возможны и задачи смешанного типа.

Задачи теории С. в. решаются приближёнными методами, приспособленными к тем или иным особенностям задачи: флуктуации случайных параметров и ϕ -дцй могут быть сильными и слабыми, главными, медленными или, наоборот, быстрыми, резкими, корреляция может быть сильной («дальней») или же слабой («короткой») и т. п. Лишь нек-рые задачи допускают простое описание. Напр., для линейного оператора \hat{L} формально просто решаются задачи схемы 1. Если известно оператор \hat{L} , ядро, k -рого есть ϕ -ция Грина задачи, то волновое поле и связано с источниками q соотношением $u = \hat{G}q$, что позволяет найти все моменты поля u : $\langle u \rangle = \hat{G}\langle q \rangle$, $\langle u_1 u_2 \rangle = \hat{G} \hat{G}^T \langle q^T q \rangle$ и т. д. Вероятностные законы распространения поля при этом явно не определяются.

К статистич. схеме 1 приводит мн. задачи акустики, радиофизики, оптики, в т. ч. задачи о тепловых флуктуациях в распределённых системах: тепловые флуктуации в волноводах и антеннах, проблемы диагностики природных сред по их тепловому излучению (атмосфера Земли и планет, поверхность океана, поверхность Луны и т. д.). Сюда же относится задача о возбуждении шумов в океане случайными источниками, расположенными на поверхности, на дне и в водной толще. Задача об излучении виртуальных случайных источников типична не только для статистич. оптики (формирование оптич. изображения в частично когерентном освещении, голография, интерферометрия), но также для дифракции звука и радиоволн (дифракция волн на случайных объектах; статистич. теория антенн, теория апертурного синтеза, дифракция частично ко-

рентных волн), для радиоастрономии (определение угл. размеров радиосточников, радиоинтерферометрия, радиодифракция, задачи рентгеноструктурного анализа и алектронной микроскопии).

Статистич. схема 2 охватывает проблему распространения волн в случайных средах, k -рая представляет интерес для оптич. и акустики, для распространения радиоволн в атмосфере и ионосфере Земли, в межпланетной, околоосферной и межзвёздной плазме, для диагностики лаб. плазмы, для акустики океана и др. В рамках этой схемы разработаны методы, k -рые удовлетворительно описывают значит. долю всех задач. Приближение однократного рассеяния (первое борновское приближение) применяют в случае достаточно слабых и мелкомасштабных (относительно длины волны) неоднородностей, когда существенно рассеяние назад и в стороны. Для больших скоплений рассеивателей, образующих мутные среды, существенно многократное рассеяние, k -рое описывают при помощи теории переноса излучения. В случае крупномасштабных неоднородностей, когда преобладает многократное рассеяние вперёд, применяют след. методы: *геометрической оптики метод* (правильно описывает лишь слабые флуктуации амплитуды на ограниченных расстояниях), *плоские возмущений метод* (учитывает дифракц. эффекты, но применим лишь в области слабых флуктуаций), *параболического уравнения приближение* (позволяет получить ур-ния для произвольных моментов и описать поведение ϕ -ции когерентности на произвольных расстояниях).

Методы теории многократного рассеяния (диаграммный метод или метод ϕ -дцй Грина) позволяют получить замкнутые ур-ния для моментов поля. В частности, с этих позиций удаётся обосновать результаты феноменологич. теорий переноса излучения. Кроме того, для расчёта флуктуаций волновых полей в случайных средах используют *Кирхгофа метод*, метод интерференц. интегралов, гибридный подход (теория однократного рассеяния назад на мелкомасштабной компоненте с использованием в качестве исходного приближения методов, учитывающих влияние крупномасштабной компоненты неоднородностей) и др.

Для решения задач схемы 3 также разработаны эфф. подходы: метод малых возмущений, метод Кирхгофа, гибридный (двухмасштабный) подход, метод ϕ -дцй Грина и др., k -рые охватывают значит. долю всех физ. проблем (см. *Рассеяние волн на случайной поверхности*).

Задачи схемы 4 сводятся к проблеме пространственно-временной обработки волновых полей в присутствии помех разл. типов. Такие проблемы изучают в радиолокации, гидроакустике, теории связи.

Задачи схемы 5 отличаются «внутр.» механизмом возникновения случайности и представляют интерес для *симуляций*, задачи о возникновении турбулентности, проблемы обоснования статистич. физики и термодинамики.

С. в. в нелинейных средах отличаются гораздо большим разнообразием, чем в линейной. В частности, нелинейное взаимодействие волн разных частот и разных направлений приводит к генерации новых волн (гармоники и субгармоники, комбинац. колебания), т. е. к существенному обогащению пространственно-временного спектра. В результате такого взаимодействия ур-ние переноса излучения, k -рое в линейной волновой теории наз. кинетич. ур-нием для волн, становится нелинейным. Ур-ния такого типа описывают поведение неравновесных распределённых систем (напр., турбулентной плазмы и поверхностного морского волнения). Возникающие стохастич. колебания не зависят от нач. условий и потому заслуживают названия с т о х а с т и ч е с к и х а в т о в о л н. Стохастич. автоволны возникают также в распределённых диссипативных системах (самоорганизующиеся системы).

При нек-рых условиях необходимо учитывать квантовый характер излучения поля, в частности в теории теплового излучения (на частотах, для к-рых энергия фотона $h\nu$ превышает тепловую энергию классич. осциллятора kT), в теории лазеров при расчете естеств. шершны линии излучения, в теории фотодрибминов (при относительно небольшом потоке фотонов), при изучении явлений группировки фотонов (см. *Квантовая оптика*), при анализе *сжатых состояний*.

Лит.: Филд и пс О. М., Диниана верхнего слоя океана, пер. с англ., 2 изд., Л., 1980; Шиффман А. С., Вопросы статистической теории антенн, М., 1970; Кларк и др. Дж., Сударшан В., Основы квантовой оптики, пер. с англ., М., 1970; Басва Ф. Г., Фукс И. М., Расcеивание волн на статистически неровной поверхности, М., 1972; Перрия Я., Когерентность света, пер. с англ., М., 1974; Даверовиче в турбулентной атмосфере, М., 1976; Введение в статистическую радиотехнику, ч. 2 — Рытов С. М., Кравцов Ю. А., Титарский В. И., Случайные процессы, М., 1978; Агеевичев С. А., Дьяков Ю. Е., Чирякин А. С., Введение в статистическую радиотехнику и оптику, М., 1981; Гочелашвили К. С., Шишов В. И., Волны в случайно-неоднородных средах, М., 1981; Исмаилов А. И., Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1981; Распространение звука во флукутирующей среде, пер. с англ., М., 1982; Заславский Г. М., Стохастичность динамических систем, Л., 1984.

Л. А. Алесан, Ю. А. Кравцов, А. Б. Шмели.

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС — ф-ция непрерывного времени $\xi(t)$, значение к-рой в каждый момент является *случайной величиной*, т. е. величиной, подчиняющейся вероятностным законам. Если аргумент t изменяется дискретно, то $\xi(t)$ наз. случайной последовательностью. Случайную ф-цию неск. непрерывных аргументов $\xi(t, u, v, \dots)$ называют переменным случайным полем. Примерами С. п. могут служить разл. физ. процессы, сопровождающиеся случайными флукутациями, а также мн. процессы в геофизике, радиотехнике, биофизике и др.

С. п. задан, если для любых моментов времени t_1, \dots, t_n известны многомерные (многоточечные) плотности вероятности $w_n(\xi_1, t_1, \dots, \xi_n, t_n)$ для совокупности случайных величин $\xi_1(t_1), \dots, \xi_n(t_n)$ либо соответствующие многомерные *характеристические функции*

$$\Phi_n(t_1, v_1, \dots, t_n, v_n) = \left\langle \exp \left(i \sum_{l=1}^n \xi_l(t_l) v_l \right) \right\rangle = \int \dots \int w_n(\xi_1, t_1, \dots, \xi_n, t_n) \exp \left(i \sum_{l=1}^n \xi_l(t_l) v_l \right) d\xi_1 \dots d\xi_n.$$

Для детерминиров. процессов $\xi = f(t)$ плотность вероятности выражается через δ -функцию, напр. $w_1(\xi, t) = \delta(\xi - f(t))$.

Исчерпывающей статистич. характеристикой С. п. является его *характеристический функционал*

$$\Phi[v] = \left\langle \exp \left[i \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) v(t) dt \right] \right\rangle,$$

где $\langle \dots \rangle$ означает статистич. усреднение по всевозможным реализациям С. п. $\xi(t)$ на интервале (T_1, T_2) . Зная $\Phi[v]$, можно получить многомерные характеристики ф-ции для $\xi_1(t_1), \dots, \xi_n(t_n)$, взяв в качестве аргумента функционала ф-цию $v(t) = \sum_{l=1}^n v_l \delta(t - t_l)$. Коэф. разложения $\Phi[v]$ в окрестности $v = 0$ определяют моменты n -ые функции M_n С. п.:

$$\Phi[v] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int \dots \int \frac{\delta^n \Phi[v]}{\delta v(t_1) \dots \delta v(t_n)} \Big|_{v=0} v(t_1) \dots v(t_n) dt_1 \dots dt_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i^n/n!)}{\dots} \int \dots \int M_n(t_1, \dots, t_n) v(t_1) \dots v(t_n) dt_1 \dots dt_n,$$

а коэф. разложения $\ln \Phi[v]$ — кумулянтные функции K_n :

$$\ln \Phi[v] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int \dots \int \frac{\delta^n \ln \Phi[v]}{\delta v(t_1) \dots \delta v(t_n)} \Big|_{v=0} v(t_1) \dots v(t_n) dt_1 \dots dt_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i^n/n!)}{\dots} \int \dots \int K_n(t_1, \dots, t_n) \times v(t_1) \dots v(t_n) dt_1 \dots dt_n.$$

Кумулянтные ф-ции 1-го и 2-го порядка характеризуют ср. значение $M_1(t) = K_1(t) = \langle \xi(t) \rangle$ и *корреляционную функцию*

$$K_2(t_1, t_2) = \langle \xi(t_1) \xi(t_2) \rangle - \langle \xi(t_1) \rangle \langle \xi(t_2) \rangle = M_2(t_1, t_2) - M_1(t_1) M_1(t_2).$$

Ф-ции $M_n(t_1, \dots, t_n)$ и $K_n(t_1, \dots, t_n)$ при $t_1 = t_2 = \dots = t_n$ определяют одноточечные моменты и кумулянтные С. п. $\xi(t)$, в частности ср. интенсивность $M_1(t) = \langle \xi^2(t) \rangle$, дисперсию $K_2(t) = \langle \xi^2(t) \rangle - \langle \xi(t) \rangle^2$, коэф. асимметрии $\chi_3 = K_3 K_2^{-3/2}$ и экспосса $\chi = K_4 K_2^{-2}$.

При ограничении сведений о С. п. либо при невозможности его полного описания часто пользуются *корреляционной теорией*, рассматривающей только одноточечные и двухточечные статистич. характеристики 1-го и 2-го порядка.

Вместо характеристик функционала иногда используют функционал плотности вероятности С. п. $w[\xi]$, к-рый является континуальным аналогом многоточечной плотности вероятности и характеризует плотность вероятности отд. реализаций С. п. $\xi(t)$. Нормировочный множитель функционала $w[\xi]$ обычно обращается в 0 или в ∞ , но это не препятствует использованию $w[\xi]$ при нахождении моментов и кумулянтных С. п., либо вероятных реализаций С. п. и т. п.

Перечисленные статистич. характеристики обобщают на комплексные и векторные (многомерные, многокомпонентные) С. п. $\xi(t) = \{\xi_1(t), \dots, \xi_n(t)\}$. Наряду с моментами и кумулянтами, характеризующими статистич. свойства отд. компонент С. п., используются также смешанные моменты и кумулянтами, описывающими взаимные статистич. связи между компонентами С. п.

Нек-рые классы С. п. представляют спец. интерес для физики.

Стационарные процессы. С. п. наз. стационарным в узком смысле, если все его многоточечные вероятностные характеристики не меняются при изменении начала отсчета времени, т. е. зависят только от разностей $t_i - t_j$. Если этим свойством обладают только ср. значение и корреляц. ф-ция, т. е. $\langle \xi(t) \rangle = \text{const}$ и $K_2(t_1, t_2) = K_2(t_2 - t_1)$, причём $K_2(0) < \infty$, то С. п. является стационарным в широком смысле. Для стационарных в широком смысле процессов имеет место *Винера — Хинчина теорема*: коррелц. ф-ция и спектральная плотность (спектр мощности) С. п. связаны друг с другом преобразованием Фурье.

Время корреляции τ_c в течение к-рого коррелц. ф-ция спадает в e раз, и ширина спектра $\Delta\omega$ связаны соотношением неопределенности $\tau_c \Delta\omega \sim 2\pi$. При $\tau_c \rightarrow 0$ величина $\Delta\omega \rightarrow \infty$ и С. п. представляет собой *белый шум*.

Квантостационарные процессы. Если зависимость многоточечных статистич. характеристик С. п. от положения на оси времени является медленной по сравнению с зависимостью от разностей $t_i - t_j$, то такой С. п. относят к классу квантостационарных. Для него можно ввести понятие мгновенной спектральной плотности.

Периодически — нестационарные процессы. У таких С. п. статистич. характеристики периодически зависят от времени, напр. $\eta(t) = F(t)\xi(t)$, где $F(t)$ — периодич. детерминированная ф-ция, а $\xi(t)$ — стационарный С. п.

Случайные процессы со стационарными приращениями. Это процессы, для к-рых, как и для стационарных процессов, сохраняются понятие спектральной плотности, но корреляция функции может и не существовать. Для статистич. описания таких С. п. пользуются не корреляционной, а структурной функцией

$$D(t_1, t_2) = \{(\xi(t_1) - \xi(t_2)) - (\xi(t_2) - \xi(t_1))\}^2,$$

равной дисперсии случайных приращений процесса на интервале (t_1, t_2) . Структурная функция стационарного процесса связана с его корреляц. функцией (если последняя существует) соотношением:

$$D(\tau) = 2[K_2(0) - K_2(\tau)].$$

Гауссовы процессы. В случае нормальных (гауссовых) процессов моментные и кумулянтные функции произвольного порядка выражаются через ср. значение и корреляц. функцию, к-рые дают, т. о., полное описание С. п. этого класса. Значит, роль гауссовых процессов в физике определяется тем, что они реализуются практически всюду, где происходит сложение многих С. п. (*центральная предельная теорема*). Однородный гауссов процесс с независимыми приращениями наз. *винеровским случайным процессом*, служит непрерывной моделью броуновского движения.

Марковские процессы (процессы без последования), для них многоточные вероятности выражаются через одномерные плотности распределения и двухточные плотности вероятности перехода.

Кроме того, выделяют ещё импульсные процессы, диффузионные процессы, ветвящиеся процессы и др. Широкий класс С. п. составляют процессы, подчиняющиеся *стохастическим уравнениям*. Трудности в интерпретации эмпирич. статистич. характеристик реальных процессов связаны с выделением статистич. ансамбля, к-рому может принадлежать ограниченный отрезок наблюдаемого процесса. При выборе статистич. ансамбля фундам. роль играет *эргодическая гипотеза*, согласно к-рой моменты гипотез. ансамбля отождествляют со средними по времени.

Лит.: Гнеденко В. В., Курс теории вероятностей, 6 изд., М., 1955; Винер в статистическую радиофизику, Ч. 1. Ротом С. М., Случайные процессы, М., 1976; Справочник по теории вероятностей и математической статистике, 2 изд., М., 1985; Яглом А. М., Корреляционная теория стационарных случайных функций, М., 1981; Ротом С. М., Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика, М., 1985. О. В. Гулянский, Ю. А. Краевец, А. Б. Шмелёв.

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС СО СТАЦИОНАРНЫМИ ПРИРАЩЕНИЯМИ — случайный процесс $\{\xi_t, t \in R^1\}$, у к-рого распределение вероятностей приращений $\Delta_t \xi = \xi_{t'} - \xi_t$ на промежутке времени $t = (t, t')$, $t' < t$ не зависит от выбора начала отсчёта времени t . Более точно это означает, что для любого набора моментов времени

$$t_1 < t_2 < \dots < t_n, \quad (*)$$

$t_i \in R^1, i = 1, \dots, n; n = 1, 2, \dots$ совместное распределение вероятностей $F_{\Delta_t \xi, \dots, \Delta_{t_n} \xi}$ приращений процесса $\xi(t)$ на промежутках между этими моментами

$$\Delta_t \xi = \xi_t - \xi_{t_1}; \Delta_{t_2} \xi = \xi_{t_2} - \xi_{t_1}; \Delta_{t_n} \xi = \xi_{t_n} - \xi_{t_{n-1}},$$

не меняется при одновременном «сдвиге» всех моментов $t_1, \dots, t_n \rightarrow t_1 + s, \dots, t_n + s$ ($s \in R^1$).

Иногда рассматривают С. п. со с. п. 2-го, 3-го, ..., к-го порядка. Так, в случае $k = 2$ это означает, что для любой последовательности моментов времени $(*)$ стационарны вторые разности процесса ξ_t :

$$\Delta_t^2 \xi = \xi_t + \xi_{t_2} - 2\xi_{t_1}, \quad t = 1, \dots, n-2.$$

В случае, когда С. п. со с. п. к-го порядка имеет к-ую производную по времени $\xi_t^{(k)}$ (что означает соответ-

ствующую гладкость его реализаций), эта производная образует *стационарный случайный процесс*.

Лит.: Гнеденко В. В., Смирнов Б. В., Выделение в теории случайных процессов, 2 изд., М., 1977; Ротом С. М., А. Милос.

С-МАТРИЦА — то же, что *матрица рассеяния*. **СМАЧИВАНИЕ** — процессы, происходящие при взаимодействиях жидкости с поверхностью тв. тела или др. жидкостей и проявляющиеся в растекании жидкости и формировании пленки т. н. адгезионного контакта, возникновении менисков в капиллярных каналах, вытеснении одной жидкости другой, образовании капель жидкости на поверхности или пузырько-пористых тел, в проникновении жидкостей в капиллярно-пористые тела. С. — следствие *адгезии* жидкости к определенной поверхности.

Положение капли жидкости на поверхности определяется поверхностными натяжениями жидкости $\sigma_{ж}$, тв. тела $\sigma_{тв}$ и на границе поверхности с поверхностью жидкости $\sigma_{жтв}$. В равновесных условиях (т. е. в отсутствие гравитации, капиллярного эффекта, хим. взаимодействия, диффузии, адсорбции и т. д.) для обратимых процессов еще задается ур-нием Юнга:

$$\cos \theta = (\sigma_{тв} - \sigma_{жтв}) / \sigma_{ж},$$

где θ — т. и. краевой угол — угол, отсчитываемый от смачиваемой поверхности в сторону смачивающей жидкости (см. рис. в ст. *Краевые углы*). С. сопровождается тепловыми эффектами, в частности выделяется т. н. теплота С.

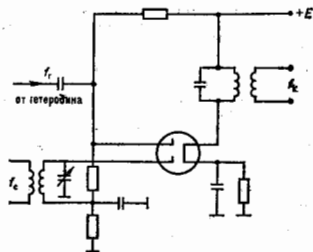
Краевой угол θ является мерой С., его величина зависит от соотношения между энергиями адгезии и когезии жидкости. Для тв. смачиваемых поверхностей (лифобных) $0^\circ < \theta < 90^\circ$, по отношению к воде, гидрофильных) $0^\circ < \theta < 90^\circ$, для несмачиваемых (лифобных, гидрофобных) $\theta > 90^\circ$. Неравновесные условия, загрязнения поверхности, изменение темп-ры и др. факторы исключают возможность полного С. или полного его отсутствия, т. е. $\theta \neq 0^\circ$ и $\theta \neq 180^\circ$. Под влиянием воздействия θ изменяется, процесс, сопровождающийся его увеличением, наз. лифобизацией поверхности, уменьшением — её лифобизацией. С. твердых поверхностей повышается при введении в смачивающую жидкость разл. веществ, напр. *поверхностно-активных веществ*, уменьшается — при нанесении на поверхность гидрофобных покрытий и т. д.

На величину θ влияет качество поверхности. Шероховатость лифобильной поверхности улучшает её С., лифобной — снижает С. Часто наблюдается задержка установления краевого угла, наз. гистерезисом С., к-рая появляется при движении капель, при воздействии внеш. сил, из-за неравномерности поверхности и т. д. Величину θ можно определить, напр., по форме и размеру капель на плоской поверхности, в капиллярах и на нитях.

С. имеет важное значение в пром-сти. На его изменение основаны мн. технологич. процессы, флотация, полиграфич. и металлургич. процессы, нефтедобыча, смазка, окраска, пропитка, стирка и т. д.

Лит.: Горюнов Ю. В., Сумин В. Д., Смачивание, М., 1972; Зимон А. Д., Адгезия жидкости и смачивание, М., 1974; его же, Что такое адгезия, М., 1983.

А. Д. Зимон.
СМЕСИТЕЛЬ в радиотехнике — преобразователь частоты, использующий всомогат. генератор гармонических колебаний (гетеродин). С. выполняет перемножение преобразуемого (с частотой f_0) и гетеродина (с частотой f_0) сигналов, в результате чего образуются сигналы с комбинац. частотами $f_c \pm f_0$. Мерой эффективности С. служит крутизна преобразования $S_{пр}$, равная отношению амплитуды тока комбинац. частоты на выходе С. к амплитуде напряжения сигнала, приложенного ко входу. Другой характеристикой С. является *шумовая температура* $T_{ш}$. Преобразование осуществляется с помощью нелинейного элемента, в качестве к-рого могут служить: кристаллич. детектор (в диапазоне СВЧ), смесительная электронная лампа,



транзистор биполярный, полевые транзистор с одним или двумя авторами (рис.), дифференциальный усилитель, сверхпроводящий туннельный переход типа сверхпроводник — изолятор — сверхпроводник. Последний даёт возможность получить преобразование с усилением и имеет такую шумовую темп-ру, близкую к квантовому пределу в ДВ-части миллиметрового диапазона. С. используется в супергерцовых приборах (см. *Супергерцовики*) для преобразования частоты принимаемого сигнала в промежуточную частоту (см. также *Детектирование сетей*).

Лит.: Гоноровский И. С., *Радиотехнические цепи и сигналы*, 4 изд., М., 1988; Манаев Е. И., *Основы радиоэлектроники*, 3 изд., М., 1990; Кошелев В. П., Овсянников Г. А., *Криогенные СВЧ устройства*, «Зарубежная радиоэлектроника. Криоэлектроника. Следящий выпуск», 1983, № 6, с. 31.

Ю. С. Константинов.

СМЕШАННОЕ СОСТОЯНИЕ (смесь состояний) — состояние квантовомеханич. системы, к-рое в отличие от *чистого состояния* не описывается *волновой функцией*. В С. с. не задан максимально полный набор независимых физ. величин, определяющих состояние системы, а определены лишь вероятности w_1, w_2, \dots нахождения системы в разл. квантовых состояниях, описываемых волновыми ф-циями ψ_1, ψ_2, \dots . Ср. значение \bar{A} к-л. физ. величины A (к-рой соответствует оператор \hat{A}) определяется в С. с. как сумма произведений вероятностей (*статистический вес*) w_i на ср. значения \bar{A}_i величин A в чистых состояниях ψ_i :

$$\bar{A} = \sum_i w_i \bar{A}_i, \quad \bar{A}_i = \int \psi_i^*(x) \hat{A} \psi_i(x) dx, \quad (1)$$

где ψ_i — волновая ф-ция в координатном представлении, полная вероятность $\sum_i w_i = 1$.

Для чистого состояния ф-лу (1) преобразованием волновых ф-ций можно привести к виду, в к-ром все вероятности w_i равны нулю, кроме одной, равной единице. Такое преобразование приводит к обычному выражению для квантовомеханич. средних; для С. с. такое приведение невозможно.

При задании оператора \hat{A} и матрицы плотности $\hat{\rho}$ в матричной форме ср. значение

$$\bar{A} = \text{Sp}(\hat{A} \hat{\rho}) = \sum_m (\hat{A} \hat{\rho})_{nn} = \sum_{m,m} A_{nm} \rho_{mn}, \quad (2)$$

причём среди индексов квантовых состояний m, n могут быть и непрерывные индексы, как в ф-ле (1). Ф-ла (2) справедлива для чистых и для смешанных состояний.

В С. с. в отличие от суперпозиции состояний (см. *Суперпозиция принципа*), разл. квантовые состояния не интерферируют между собой, т. к. при определении среднего складываются не волновые ф-ции, а ср. значения. Примеры С. с. — неполяризов. пучок частиц,

газ в термостате. Понятие С. с. играет большую роль в квантовой статистике и теории измерений в *квантовой механике*. Статистич. операторы, соответствующие *Гиббса распределению*, описывают С. с. Д. Н. Зубарев. **СМЕШАННОЕ СОСТОЯНИЕ** сверхпроводников (в Шубникова фазе) — особое состояние *сверхпроводников второго рода*. С. с. реализуется в интервале магн. полей от нижнего (H_{c1}) до верхнего (H_{c2}) критического магнитного поля. Существование С. с. продемонстрировано Л. В. Шубниковым в экспериментах со сверхпроводящими сплавами (1937). Теоретич. обоснование возникновения С. с. дано А. А. Абрикосовым (1957).

В магн. полях выше H_{c1} сверхпроводник переходит в нормальное (несверхпроводящее) состояние. В полях ниже H_{c1} магн. поле полностью выталкивается из массивного сверхпроводника (полный *Мейснера эффект*). При С. с. наблюдается неполный эффект Мейснера. Магн. поле проникает в сверхпроводник в виде абрикосовских вихрей — вихрей сверхпроводящего тока, несущих *квант магнитного потока*; в центре вихря (область размером порядка длины когерентности) *сверхпроводимость* подавлена. В поле H_{c1} возникает первый вихрь. С увеличением поля кол-во вихрей возрастает, а расстояние между ними уменьшается. Они образуют правильную (в отсутствие дефектов структуры) *решётку вихрей Абрикосова*. В поле H_{c2} нормальные области (центры вихрей) начинают перекрываться, и весь сверхпроводник переходит в нормальное состояние.

Лит.: Жей П. Ж. де, *Сверхпроводимость металлов* в силах, пер. с англ., М., 1968; Сан Жам Д., Сарма Г., Томас Е., *Сверхпроводимость второго рода*, пер. с англ., М., 1974.

СМЕЩЕНИЯ ТОК — величина, плотность к-рой ($J_{см}$) определяет скорость изменения во времени индукции электрич. поля D , $J_{см} = (\nabla \cdot D) / \partial t$ (в гауссовой системе единиц). Наряду с «обычным» электрич. током $J_{см}$ входит в *Максвелла уравнения* и является источником магн. поля H :

$$\text{rot } H = (\nabla \times J) + J_{см} \quad (*)$$

(J — плотность «обычного» электрич. тока). С. т. введён в 1865 Дж. К. Максвеллом (J. C. Maxwell) для согласования ур-ний переменного эл.-магн. поля с ур-нием сохранения электрич. заряда. Часть $J_{см}$, называемая плотностью тока поляризации $J_{п}$, обусловлена изменением во времени вектора поляризации P , $J_{п} = \partial P / \partial t$, и представляет собой электрич. ток, связанный с реальным смещением микрочарядов, входящих в состав нейтральных атомов, молекул, скопления свободных заряд. частиц или кваинейтральной плазмы.

Для обоснования добавочного члена в ур-нии (*) Максвелл постулировал аналогию между диэлектрич. и механич. упругой средами. Согласно этой аналогии, под действием приложенного электрич. поля E в диэлектрич. среде происходит электрич. смещение (т. е. относительное смещение положит. и отрицат. электр. зарядов в электрич.ски нейтральной среде), пропорциональное приложенному полю. Изменению во времени этого смещения представляет собой такой же электрич. ток, как и ток проводимости. Суммарный ток в ур-нии (*) Максвелл считал полным током в среде и называл его *истинным током*. В совр. электродинамике идея Максвелла об электрч. смещении фактически не используется, но вектор D иногда называют электрич. смещением.

Введение С. т. в ур-ние (*) позволило Максвеллу предсказать существование эл.-магн. волн, высказать гипотезу об эл.-магн. природе света и вычислить скорость света в вакууме через электродинамич. постоянные, входящие в ур-ние эл.-магн. поля.

Лит.: Максвелл Дж. К., *Трактат об электрич. и магнитн. яв.* Классики естествознания, пер. с англ., т. 1-2, М., 1989; Максвелл и развитие физики XIX — XX вв., М., 1985; см. также лит. при ст. *Максвелла уравнения*.

СМОЛУХОВСКОГО УРАВНЕНИЕ — дифференциальное уравнение, описывающее эволюцию распределения вероятностей для пространственного положения броуновской частицы. Пусть $w(x, t)$ — плотность вероятности того, что броуновская частица (см. *Броуновское движение*) в момент времени t находится в точке $x \in \mathbb{R}^3$. Тогда в предположении, что на эту частицу действует переменное силовое поле $K(x, t)$, плотность w удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению:

$$\partial w / \partial t = D \Delta w - \beta w \operatorname{div} K,$$

где Δ — Лапласа оператор, D и β — параметры, определяемые массой частицы, вязкостью, темп-рой среды и т. д.

Это уравнение впервые было выведено М. Смолуховским и явилось прообразом более общих дифференциальных уравнений в теории марковских диффузионных процессов (Фоккера — Планка уравнение, Колмогорова уравнения).

Лит.: Смолуховский М., Über Brownsche Molekularbewegung unter Einwirkung einer Kraft und deren Zusammenhang mit der verallgemeinerten Diffusionsgleichung, Ann. Phys., 1915, Bd 48, S. 1163; Гихман И. И., Скороход А. В., Теория случайных процессов, т. 2, М., 1973.

СНЕЛЛИЯ ЗАКОН преломления — закон преломления света на границе двух прозрачных сред, утверждающий, что при любом угле падения α отношение $\sin \alpha / \sin \beta$ (β — угол преломления) является величиной постоянной. Установлен В. Снеллием (W. Snellius) в 1620 и независимо от него в 1627—30 Р. Декартом (R. Descartes). На основе С. з. стало возможным ввести понятие преломления показателя. См. также *Преломление света*.

СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ — проводимость полупроводника, обусловленная электронами, возбужденными на валентной зоне в зону проводимости и дырками, образовавшимися в валентной зоне. Концентрации n_i таких (зонных) электронов и дырок равны, и их можно выразить через эфф. плотности состояний в зоне проводимости (N_c) и в валентной зоне (N_v), ширину запрещенной зоны E_g и абс. темп-ру T :

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp(-E_g / 2kT).$$

Т. к. проводимость σ полупроводника пропорциональна концентрации свободных носителей заряда и их подвижности μ , то в пребрежении слабыми степенными зависимостями N_c , N_v и μ от темп-ры для собств. полупроводников можно получить соотношение:

$$\sigma(T) \propto \exp(-E_g / kT).$$

При наличии примесей, обуславливающих примесную проводимость полупроводника, С. п. можно наблюдать в диапазоне изменения темп-ры полупроводника, в к-ром зависимость $\ln \sigma(T)$ линейна.

Лит.: см. при ст. *Полупроводники*. И. Л. Бейлихес.
СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОТСЧЕТА — система отсчета, связанная с рассматриваемым телом так, что все точки этого тела покоятся относительно неё. Такии образом, С. с. о. движется вместе с рассматриваемым телом и в общем случае произвольного движения не инерциальна и вращается. Если тело ограничено в пространстве, то вне его С. с. о. может быть продолжена, вообще говоря, произвольным образом и не определена однозначно (она может, напр., деформироваться с течением времени). Однако и нек-рых важных частных случаях существует физически преимушеств. выбор С. с. о. вне тела. Так, если тело жесткое и движется по инерции без вращения, то С. с. о. внутри и вне тела может быть выбрана как жесткая инерциальная система отсчета (и. с. о.). В случае призматического ускоренного движения жесткого тела без вращения С. с. о. хотя и не инерциальна, но также может быть жесткой внутри и вне тела. Однако в этом случае жесткая С. с. о. уже не может быть продолжена в пространстве вне тела неограниченно, т. к. силы инерции в разл. точках разные и неадекватно растут при сдвигении

на конечное расстояние в направлении действия этих сил. Действительно, скорость v ускоренной системы по отношению к фиксированной и. с. о. с течением времени возрастает, а порождено сокращение увеличивается. Поэтому адекват по ходу движения концы жесткого тела, покоящегося в ускоренной системе, будут «дологаться» передний. Т. о., разл. точки тела будут иметь разные ускорения, а следовательно в них будут и разные силы инерции f по отношению к и. с. о. при этом, когда $v \rightarrow c$, $f \rightarrow \infty$. Так, если нек-рая точка системы испытывает ускорение g , то на расстоянии $l = c^2/g$ от этой точки силы инерции $f \rightarrow \infty$. Чтобы в этом случае ввести С. с. о., к-рую можно продолжить во всем пространстве, её выбирают деформирующейся. При более сложных движениях тела, а также если само тело деформируется с течением времени, С. с. о. также должна быть выбрана деформирующейся. Это же вывод справедлив при движении тела в поле тяготения. При рассмотрении движения деформирующейся непрерывной среды С. с. о. часто называют сопутствующей в системе отсчета. См. *Относительность теории тяготения*. И. Д. Новиков.

СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА — частота нормальных колебаний или нормальных волн динамич. системы. **СОБСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ЧАСТИЦЫ** — энергия частицы θ_0 в собственной системе отсчета, т. е. в той системе, в к-рой она покоится: $\theta_0 = m_0 c^2$ (m_0 — масса покоя частицы). С. э. ч. называют также *энергией покоя*.

СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ — время, измеряемое часами, движущимися вместе с рассматриваемым телом, т. е. время в собственной системе отсчета. Время протекания к-л. процесса, измеряемое внеш. наблюдателем, мимо к-рого движется тело, зависит от относительности движения. Если измерения проводятся наблюдателем в инерциальной системе отсчета, то собств. промежуток времени τ , протекajúщий на движущемся теле, связан с временем t системы отсчета θ фл:

$$\tau = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - v^2(t)/c^2} dt, \quad (1)$$

где $v(t)$ — скорость движения тела. Промежуток τ является длиной отрезка мировой линии данного тела, деленной на c . В общем случае при измерениях времени в произвольной (неинерциальной) системе отсчета и при наличии полей тяготения фл-а (1) заменяется след. выражением:

$$\tau = c^{-1} \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{g_{00} + 2g_{0i}x^i + g_{ik}x^i x^k} d\theta, \quad (2)$$

где g_{00} , g_{0i} , g_{ik} — компоненты фундаментальной метрич. тензора (по дважды встречающимся индексам подразумевается суммирование $i, k = 1, 2, 3$), $x^i = ct$, x^i — компоненты скорости движения тела. Если тело покоится в статич. слабом поле тяготения, то фл-а (2) принимает вид:

$$\tau = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 + \varphi/c^2} dt,$$

где φ — ньютоновский потенциал поля тяготения. Т. к. $\varphi < 0$, то С. в. в поле тяготения течёт медленнее, чем вне его. См. *Относительность теории тяготения*. И. Д. Новиков.

СОБСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ линейного оператора A , отвечающего собственному вектору (собственной функции) f из линейного пространства (векторного пространства) L , — комплексное либо вещественное число λ , такое, что

$$Af = \lambda f.$$

Совокупность всех собств. ф-ций, отвечающих одному и тому же С. з. λ , образует линейное подпространство

L_1 пространства L . Размерность L_1 наз. кратностью C . з. Если пространство L конечномерно, то C . з. совпадают с корнями характеристического многочлена, $\det \|A - \lambda I\|$, где A — матрица линейного преобразования A в нек-ром базисе, I — единичная матрица. Если оператор A самосопряжён (эрмитов оператор), то все его C . з. вещественны. В квантовой механике вещественные C . з. самосопряжённого оператора отвечают значениям наблюдаемых (измеряемых) величин. В частности, у каждой конечномерной эрмитовой $n \times n$ -матрицы A найдутся (с учётом кратностей) ровно n C . з.

В бесконечномерном случае можно сформулировать аналог этого утверждения для самосопряжённых компактных операторов. Оператор A , действующий, напр., в пространстве P бесконечномерных векторов $f = (a_1, a_2, \dots)$ с конечной нормой

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$$

и соответствующим скалярным произведением, наз. компактным, если он переводит любую ограниченную последовательность векторов $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ (т. е. такую, что для всех n выполнено неравенство $\|x_n\| < M$) в последовательность $\{Ax_n\}_{n=1}^{\infty}$, из к-рой всегда можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Отсюда, в частности, следует, что если выбрать последовательности $\{x_n\}$ ортонормированной: $(x_n, x_m) = 1$ при $n = m$ и 0 при $n \neq m$ [примером такой последовательности служат $x_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$], то последовательность $\{Ax_n\}$ будет сходиться к нулю. Для таких операторов, действующих в пространстве P или в функциональных пространствах, справедлива теорема Рисса — Шапурова, утверждающая, что система собств. ф-ций (собств. векторов) такого оператора образует базис (полную систему из ортонормированных ф-ций) в соответствующем пространстве, а его C . з. λ_n сходятся к нулю при $n \rightarrow \infty$, причём каждое C . з. является корнем конечной кратности. К классу компактных операторов относятся все ограниченные интегральные операторы с интегрируемым ядром, к-рые часто встречаются в физике, напр. в задачах с потенциалами.

Класс компактных операторов оказывается слишком узким, чтобы описать все физически интересные случаи. Он не описывает унитарные операторы (т. е. операторы, сохраняющие норму; все C . з. таких операторов представляются в виде $e^{i\varphi}$, $\varphi \in \mathbb{R}$), а также дифференциальные операторы, к-рые, как правило, не ограничены. Обобщением понятия C . з. для таких операторов служат понятие спектра $\sigma(A)$ оператора A . Число λ принадлежит спектру оператора, если резольвента оператора A , $R(\lambda) = (\lambda I - A)^{-1}$, будет сингулярным оператором. Все C . з. A будут принадлежать $\sigma(A)$ [она будут изолированными (дискретными) точками $\sigma(A)$]. Однако помимо этих точек $\sigma(A)$ обычно содержит непрерывную часть, состоящую из таких точек λ , для к-рых оператор $R(\lambda)$ определён, но не ограничен. В обычном смысле таким λ не соответствует никакая собств. ф-ция, тем не менее анализ разложения по базису собств. ф-ций задаётся спектральным разложением.

Лит. см. при ст. Собственные функции. Д. О. Чехов. **СОБСТВЕННЫЕ ВОЛНЫ** — то же, что нормальные волны.

СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ — колебания, происходящие в колебательной системе в отсутствие внешних воздействий; то же, что свободные колебания.

СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ оператора, действующего в функциональном пространстве, — ненулевые ф-ции f_n , переводящиеся оператором A в пропорциональные им:

$$A f_n = \lambda_n f_n.$$

Комплексное либо вещественное число λ наз. собственным значением оператора A . В гильбертовом пространстве $L^2(\Omega, d\mu)$ ф-ция ψ на множестве Ω , интегрируемая с квадратом по мере $d\mu$, в к-ром задано скалярное произведение ф-ций

$$\langle f, \psi \rangle = \int_{\Omega} f^*(x)\psi(x)d\mu(x)$$

(звёздочка означает комплексное сопряжение) и вводится понятие сопряжённого оператора, особенно важную роль играют самосопряжённые линейные операторы (эрмитовы операторы, в дальнейшем линейность операторов подразумевается). Это такие операторы, для к-рых $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ для всех x и y из $L^2(\Omega, d\mu)$ (эти скалярные произведения имеют смысл), множества всех допустимых ф-ций x и y должны совпадать; все собств. значения таких операторов вещественны. В квантовой механике с каждой наблюдаемой ассоциируется самосопряжённый оператор. C . ф. к-рого задают состояние системы с определённым значением оператора наблюдаемой. Напр., для гармонич. осциллятора оператор энергии (гамильтониан)

$$H = -\frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} x^2,$$

C . ф. к-рого являются функции Эрмита, ортогональные на $]-\infty, +\infty[$. При этом к-й C . ф. $\Psi_k(x) = (\sqrt{\pi} 2^k k!)^{-1/2} (x - d/dx)^k \exp(-x^2/2)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) соответствует собств. значение $\lambda_k = k + 1/2$.

C . ф. f_1 и f_2 самосопряжённого оператора A , отвечающие разл. собств. значениям λ_1 и λ_2 , ортогональны, $\langle f_1, f_2 \rangle = 0$. Множество L_1 всех C . ф., отвечающих одному собств. значению λ , образует линейное подпространство, совпадающее с ядром оператора $A - \lambda I$ (I — единичный оператор), т. е. с множеством ф-ций, переводимых этим оператором в 0 (ядром оператора B наз. множество ф-ций f , для к-рых $Bf = 0$).

В приложениях (вариант. исчисление, классич. граничные задачи матем. физики) важную роль играют самосопряжённые интегральные операторы K :

$$(Kf)(x) = \int_{\Omega} K(x, y)f(y)d\mu(y),$$

ф-ция $K(x, y) = K^*(y, x)$ наз. ядром интегрального оператора (не путать с понятием ядра оператора, определённым выше). Если оператор K ограничен, а его ядро — интегрируемая ф-ция, то K компактен и его C . ф. образуют базис в пространстве $L^2(\Omega, d\mu)$. Ядро $K(x, y)$ такого оператора можно разложить (в конечною либо бесконечною) сумму:

$$K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \varphi_n^*(x) \varphi_n(y), \quad (*)$$

где $\varphi_n(x)$ — набор (всегда конечный при данном n) ортонормированных C . ф., отвечающих одному и тому же собств. значению λ_n , при этом $|\lambda_n| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Примером такого интегрального оператора может служить решение Дирихле задачи. Одним из критериев ограниченности является условие $K(x, y) \in L^2(\Omega \otimes \Omega, d\mu \otimes d\mu)$, т. е. ф-ция $K(x, y)$ интегрируема с квадратом по своим аргументам.

Класс самосопряжённых операторов, действующих на всём гильбертовом пространстве ф-ций $L^2(\Omega, d\mu)$, слишком узок, чтобы охватить все физически интересные величины. Не все даже ограниченные операторы имеют разложение (*). Напр., унитарный оператор сдвига $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x+a)$ не имеет C . ф. в пространстве $L^2(]-\infty, +\infty[)$, то же справедливо и для неограниченных операторов, к к-рым относятся практически все дифферен-

циальные операторы. Для таких операторов понятие С. ф. обобщается в т. в. спектральном разложении. Рассмотрим спектр оператора $A, \sigma(A) \subset \mathbb{C}$. Если число $\lambda \in \sigma(A)$, то резольвента оператора $A, R(\lambda) = (\lambda I - A)^{-1}$, сингулярна на \mathcal{H} . Все особые значения A оказываются особыми точками $R(\lambda)$ [поскольку в них найдётся $f_\lambda(x) \in \mathcal{H}$ такая, что $(\lambda I - A)f_\lambda = 0$ и обратного оператора на всём \mathcal{H} не существует]. Но помимо таких особенностей у $R(\lambda)$ будут и др. особые точки $\lambda \in \sigma(A)$, в к-рых оператор $R(\lambda)$ определён, но неограничен. Спектральная теорема утверждает, что всякий самосопряжённый оператор A допускает спектральное разложение вида

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda dE_\lambda.$$

Здесь E_λ — ортогональное семейство проекционных операторов, проектирующих на подпространство ф-ций в $L^2(\Omega, d\mu)$ таких, что $\langle f, A f \rangle \leq \lambda \langle f, f \rangle$. Для самосопряжённого оператора A , ядро к-рого допускает разложение (*) на С. ф. $\{\varphi_k(x)\}$, E_k будут интегральными операторами с ядром (спектральным)

$$E_k(x, y) = \sum_{\lambda_k \in (-\infty, \lambda]} \varphi_{n_k}^*(x) \varphi_{n_k}(y).$$

Рассмотрим спектральное разложение оператора импульса $P = (i/\hbar) \hbar dx$, действующего на прямой (см. Операторы). Его С. ф. e^{ikx} не принадлежит пространству $L^2(-\infty, +\infty)$ (хотя могут быть аппроксимированы ф-циями из L^2 на любом конечном отрезке). Всякий оператор $(P + i\epsilon)^{-1}$ будет неограничен для любого вещественного ϵ ; т. о., спектр $\sigma(P) = \mathbb{R}$.

Для того чтобы построить спектральное разложение самосопряжённого оператора A , можно найти унитарное преобразование U пространства ф-ций \mathcal{H} и набор спектральных мер ν_1, \dots, ν_N (наличие целого набора спектральных мер вместо одной обобщает понятие кратности собств. значения λ), таких, что

$$U: \mathcal{H} \rightarrow \bigoplus_{n=1}^N L^2(\mathbb{R}, d\mu_n),$$

т. е. оператор U переводит всё пространство ф-ций \mathcal{H} в набор подпространств, внутри каждого из к-рых оператор A действует как оператор умножения:

$$(UAU^{-1}\psi)_n(x) = \lambda \psi_n(x).$$

Для оператора импульса P таким унитарным преобразованием будет Фурье преобразование:

$$(Uf)(k) = (2\pi)^{-1/2} \int f(x) \exp(-ikx) dx.$$

Тогда

$$U\left(\frac{1}{i} \frac{d}{dx} f\right)(k) = k(Uf)(k),$$

а Фурье-образом проекционного оператора $E_k(x, y)$ будет оператор умножения на ф-цию $E_k(k) = \theta(\lambda - k)$, $\theta(k) = 1, k \geq 0$; $\theta(k) = 0, k < 0$:

$$U(E_k f)(k) = \theta(\lambda - k)(Uf)(k).$$

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика. Нерелятивистская теория, 4 изд., М., 1989; Р и с с Ф., С е к е ф а л в и - Н а й в В., Лекции по функциональному анализу, пер. с франц., М., 1954; И о с и д а К., Функциональный анализ, пер. с англ., М., 1987; Р и д М., С а Я м о н о в Б., Методы современной математической физики, пер. с англ., т. 1 — Функциональный анализ, М., 1977; Математическая энциклопедия, т. 8, М., 1985. Л. О. Чехов.

СОБСТВЕННЫЙ ВЕКТОР оператора A — ненулевой вектор из векторного пространства L , к-рый переводится данным оператором в пропорциональный ему вектор, т. е.

$$Az = \lambda z,$$

где вещественное либо комплексное число λ наз. *собственным значением* оператора A . С. в. операторов, действующих в функциональном пространстве, наз. *собственными функциями*.

Для линейного оператора A множество L_λ всех С. в., отвечающих одному и тому же собств. значению λ , образует линейное подпространство, к-рое наз. *собств. подпространством* A . Если пространство L конечномерно (n -мерно), а матрица преобразования A эрмитова, то у неё имеется ровно n различных С. в., отвечающих вещественным собств. значениям.

Наличие С. в. у операторов в бесконечномерных пространствах — явление довольно редкое, хотя для физ. приложений существенно, что операторы спец. классов (интегральные, дифференциальные и т. п.) часто обладают обширными наборами С. в. Наиб. важным для физики бесконечномерным векторным пространством является пространство P векторов f, g вида (a_1, a_2, \dots) ,

(b_1, b_2, \dots) со скалярным произведением $(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ (здесь означает комплексное сопряжение) и соответствующей конечной нормой $\|f\|^2 = (f, f) < \infty$. Это пространство изоморфно пространству квадратично интегрируемых ф-ций $L^2(-\infty, +\infty)$ и обладает всеми свойствами последнего.

В конечномерных пространствах, наоборот, у всякой n -мерной матрицы A имеется хотя бы один С. в., отвечающий, вообще говоря, комплексному собств. значению λ , а если к тому же матрица A невырождена, $\det A \neq 0$, то у такой матрицы найдутся ровно n реал. комплексных С. в. Это справедливо, в частности, для унитарных конечномерных матриц $A(A^* = A^{-1})$. В физ. приложениях часто возникает необходимость разложить произвольный вектор в сумму по С. в. заданной эрмитовой матрицы A [напр., привести к диагональному виду симметричную квадратичную форму (z, Az)]. Эта задача решается переходом с помощью унитарного преобразования к *базису*, составленному из С. в. матрицы A . В этом базисе действие оператора A сводится к умножению каждого базисного вектора на соответствующее ему собств. значение λ . В бесконечномерном случае аналогом этой процедуры диагонализации является т. н. спектральное разложение.

Лит. см. при ст. *Собственные функции*. Л. О. Чехов.

СОБЕРМЕННЫЙ ГАЗ в гидроаэромеханике — газ, параметры к-рого удовлетворяют Клапейрона-уриону $P = \rho \mu(R, T)$ (P — давление, ρ — плотность, R — газовая постоянная, μ — молярная масса). С. г. имеет постоянные уд. теплотыности при постоянном объёме давлений (соотв. C_V и C_P). В гидродинамике такой газ наз. *идеальным газом*; в термодинамике и газовой динамике под идеальным газом понимают газ, в к-ром отсутствует вязкость и теплопроводность (см. *Идеальная жидкость*). Модель С. г. удовлетворительно описывает поведение реальных газов и газовых смесей (напр., воздуха) в ограниченном диапазоне изменения P и T и широко используется при расчёто-теоретич. исследованиях течения газов.

С. Л. Вышнеговский.

СОПЛАДЕНИЯ МЕТОД — эксперим. метод физики элементарных частиц и ядерной физики, основанный на регистрации неск. событий (рождение и распад частиц, пролёт их через детектор и др.), совпадающих во времени или разделённых фиксиров. промежутками времени. Примером может служить регистрация протона частицы через неск. детекторов — сантиметрационных, газоразрядных и др. (рис. 1). Сигналы, поступающие от детекторов D_1, D_2, \dots, D_n , предварительно проходят через линии задержки L_1, L_2, \dots , позволяющие регулировать времена появления сигналов на их выходе. Затем импульсы формируются по амплитуде и длительности в формирователях F или только по амплитуде в дискриминаторах D . Эти поступающие на схему совпадений $СС$, к-рая срабаты-

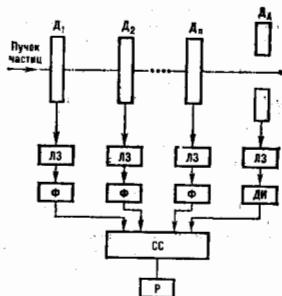


Рис. 1. Блок-схема, позволяющая регистрацию пролёта частицы через детекторы Д₁, Д₂, ..., Д_n; Д_n — детектор, включённый в схему антисовпадений; ДИ — дискриминатор с инвертированным выходом.

вает только от импульсов с длительностью и амплитудой, задаваемыми формирователем или дискриминатором. С выхода СС сигнал фиксируется регистрирующим устройством Р, напр. т. н. пересчётным прибором, к-рый фиксирует количество импульсов за определ. промежуток времени.

Времена задержек сигналов в ЛЗ подбираются так, чтобы сигналы с детекторов для регистрируемого события появлялись на входе СС одновременно. ЛЗ позволяет компенсировать разницу времён пролёта частицы через детекторы и разницу времён прохождения сигнала по кабелям и формирователям от детектора до СС.

С. м. сводится к регистрации сигналов от детекторов, совпадающих во времени на входе СС. Совпадающими наз. сигналы, полностью или частично перекрывающиеся во времени. Временной отбор сигналов осуществляется СС, к-рая реализует логич. функцию «и» (логич. умножение, см. Логические схемы), т. е. на её входе сигнал появляется лишь тогда, когда на все входы одновременно приходят импульсы определ. полярности.

Если на один или несколько из входов СС подать сигнал с инвертир. полярностью, то СС превращается в схему антисовпадений. На выходе СС сигнал может появиться только в тот промежуток времени, когда на этих входах нет сигнала с соответствующих детекторов. На рис. 1 показан детектор Д_n, включённый в схему антисовпадений и выделяющий узкий пучок частиц (напр., сингилляны, детектор с отверстием по оси пучка). Сигнал от Д_n, сформированный по амплитуде и инвертированный в дискриминаторе, подаётся на СС, к-рая выделяет частицы, пролетающие через все детекторы, но не пролетающие через Д_n.

Схема совпадения СС характеризуется числом каналов и связанным с ними детекторов (кратность). Степень разброса времён прихода сигналов, при

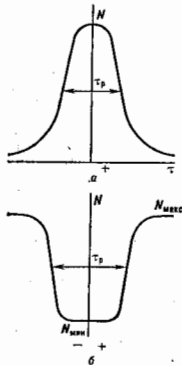


Рис. 2. Зависимость скорости счёта N на выходе схемы совпадения от задержки: а — в канале совпадения (кривая совпадения); б — в канале антисовпадения (кривая антисовпадения).

к-ром сбрасывается СС, определяется её разрешающим временем τ_p . Если измерить зависимость скорости счёта N на выходе СС от величины задержки τ в одном из каналов совпадения, то получится кривая совпадения (рис. 2, а). Разрешающим временем τ_p в данном канале наз. ширина на половине высоты максимума кривой совпадения. Если изменить задержку в канале антисовпадения, то получим кривую антисовпадения (рис. 2, б), к-рая определяет τ_p антисовпадений.

В зависимости от типа детекторов и эксперимента существуют медленные СС ($10^{-7} < \tau_p < 10^{-6}$ с), быстродействующие ($10^{-3} < \tau_p < 10^{-7}$ с) и сверхбыстродействующие ($\tau_p \leq 10^{-9}$ с).

Важной характеристикой СС является т. н. коэф. отбора $K = A_n/A_{n-1}$, где A_n — амплитуда выходного сигнала СС при совпадении в n каналах (антисовпадения исключаются), A_{n-1} — при совпадении в $(n-1)$ каналах. Коэф. K должен быть велик, иначе A_n будет мало отличаться от A_{n-1} , и совпадения трудно будет отличить от их отсутствия. Чувствительностью СС наз. мин. амплитуда сигнала на её входе, вызывающая сигнал на выходе. Иногда формирующие устройства на входе выполняются вместе с СС в одном блоке.

Истинные совпадения, связанные с исследуемым явлением (неск. детекторов регистрируют одну и ту же частицу), следует отличать от случайных совпадений (фона), обусловленных шумами детекторов или частицами, случайно прошедшими через детекторы за время τ_p (разные частицы через разные детекторы). Можно показать, что для двухканальной СС число случайных совпадений в 1с $N_{сл} = 2N_1N_2\tau_p$, для трёхканальной $N_{сл} = 4N_1N_2N_3\tau_p^2$, где N_1, N_2, N_3 и т. д. — ср. числа импульсов в 1 с, регистрируемых отд. детекторами. Для уменьшения $N_{сл}$ необходимо увеличить число детекторов n , регистрирующих истинные совпадения, или уменьшить τ_p . Увеличение n из-за конечной эффективности каждого детектора уменьшает вероятность регистрации истинных совпадений, т. е. уменьшает эффективность СС. Уменьшение τ_p также ограничено свойствами детекторов: интервал времени от пролёта частицы через детектор до появления сигнала на выходе детектора τ_d (задержка) статистически колеблется. В *сцинтилляционных детекторах*, напр., это колебание обусловлено их геом. размерами и местом прохождения частицы. Для того чтобы эффективность счёта истинных совпадений не уменьшалась, необходимо условие $\tau_p > \tau_d$. Конечное время нарастания импульсов на выходе детекторов в их амплитудный разброс также приводит к дополнительной флуктуации момента сбрасывания СС, затрудняя использование малого τ_p при высокой эффективности.

При регистрации процессов в пучках частиц высокой интенсивности возникает задача получения т. н. эффективных антисовпадений. Эффективными наз. антисовпадения, к-рые позволяют получить макс. подавления счёта, т. е. наименьшую относит. скорость счёта $N_{мин}$ в минимуме кривой антисовпадений (рис. 2, б) при макс. скорости счёта $N_{макс}$ за пределами τ_p . Уровень подавления определяется т. н. физ. и схемной неэффективностью антисовпадений. Физ. неэффективность обусловлена случайными совпадениями сигналов детекторов в каналах совпадений, конечной эффективностью регистрации частиц детектором антисовпадений и т. д. Схемная неэффективность определяется прохождением сигналов на выход схемы антисовпадений, хотя сигналы от детекторов антисовпадений превышают порог сбрасывания формирующих устройств в каналах антисовпадений и появляются во времённом интервале τ_p кривой антисовпадений. Одна из причин схемной неэффективности — т. н. мёртвое время формирующих устройств. На рис. 1 в канале антисовпадений формирование сигнала осуществляется дискриминатором ДИ, имеющим меньшее мёртвое время, чем формирующее Ф. Осн. требование к каналу антисовпадений: мёртвое

время устройства, формирующего сигнала, не должно превышать их длительности или должно отсутствовать. Для достижения эффективности антисовпадений необходимо превышение длительности сформированного сигнала в канале антисовпадений над его мёртвым временем на величину, минимальную и достаточную для перекрытия длительности и разброса времени появления сигналов совпадений на входе СС, необходимо также минимизировать длительность и разброс времени появления сигналов со всех детекторов.

Помимо ядерной физики и физики элементарных частиц С. м. применяется как метод измерений, основанный на сопоставлении ряда чередующихся сигналов, соответствующих значениям измеряемой величины, с рядом сигналов, относящихся к известной величине. Определение измеряемой величины производится по совпадению сигналов. К С. м. можно отнести, в частности, стробоскопич. метод измерения частоты механич. и эл. магн. колебаний.

Лит.: Гольдманский В. Н., Кущенко А. В., Подгорская М. И., Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц, М., 1959; Схеменная эффективность антисовпадений при регистрации частиц высокой энергии, Сергучев, 1969; Ко в а л д с к и й Я., Физика электроники, пер. с англ., М., 1972; Эффективные антисовпадения при больших нагрузках детекторов, Сергучев, 1978; Р е х и н Е. И., Ч е р н о в П. С., Васильев С. П., Метод совпадений, М., 1979; Гольдманский, В. Н.

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО — электрич. цепь или электронное устройство, к-рое обеспечивает оптим. условия передачи энергии от источника сигнала к нагрузке (приёмнику) путём преобразования выходного сопротивления источника или входного сопротивления нагрузки.

При заданном напряжении источника мощность сигнала, поступающая в нагрузку, максимальна, если выходное сопротивление источника ($Z_{\text{в}} = R_{\text{в}} + jX_{\text{в}}$) и сопротивление нагрузки ($Z_{\text{н}} = R_{\text{н}} + jX_{\text{н}}$) удовлетворяют условиям согласования: $R_{\text{в}} = R_{\text{н}}$, $X_{\text{в}} = -X_{\text{н}}$. Для получения макс. мощности в случае, когда эти условия не выполняются, между источником и нагрузкой включается реактивная цепь (без потерь), такая, что входное сопротивление этой цепи с подключённой к выходу нагрузкой удовлетворяет условиям согласования. Поскольку сама цепь не расходует энергию источника, в нагрузку передаётся макс. мощность. Обычно в качестве С. у. используется **трансформатор**.

В области высоких и сверхвысоких частот, когда длина линии передачи (двухпроводной линии, коаксиальной линии, волновода и др.) превышает длину волны сигнала, С. у. служит для устранения отражения сигнала от нагрузки, подключённой к линии. Отражение отсутствует, когда сопротивление нагрузки равно **волновому сопротивлению** линии. Если нагрузка не удовлетворяет этому условию, к линии вблизи нагрузки подключается С. у., и его электрич. параметры и место подключения выбираются так, что волны, отражённые от нагрузки и С. у., взаимно уничтожаются. В качестве С. у. применяются четвертьволновые отрезки линий (четвертьволновые трансформаторы), короткозамкнутые отводы от линии (шлейфы), отражающие перегородки в волноводах (диафрагмы), и др. Простейшие С. у. обычно укомплектованы. Для согласования в широком интервале частот служат многоэлементные С. у. сложной структуры.

В качестве С. у. также широко применяются электронные усилители, в к-рых устанавливаются требуемые значения входного и выходного сопротивлений (напр., путём регулирования отрицательной обратной связи). Для согласования источника, обладающего высоким сопротивлением, и нагрузки с малым сопротивлением обычно используют **повторители напряжения**.

Лит.: А. В. Степанов. **СОЛЕНОИД** (от греч. solén — трубка и éidos — вид) — проводящая спираль, с током, характеризующаяся числом витков на единицу длины n , длиной l , диаметром d ; толщина провода и шаг спирали (винтовой линии) ма-

лы по сравнению с d и l . Термин «С.» применят и в более широком значении — так называют катушки с произвольным сечением (квадратной С., прямоуг. С.), и не обязательно цилиндрические (тороидальный С.). Различают длинный С. ($l \gg d$) и короткий ($l \ll d$). В тех случаях, когда соотношение между d и l специально не оговаривается, подразумевается длинный С. В теоретич. физике моделью С. служит система поверхностных токов $j_{\text{в}}$, текущих по цилиндрич. поверхности перпендикулярно к образующей ($j_{\text{в}} = nI$, где I — ток моделируемого С.).

С. изобретён в 1820 А. Ампером (А. Ampère) для усиления открытого Э. Эрстедом (Н. Oersted) магн. действия тока и был применён Д. Араго (D. Arago) в опытах по намагничиванию стальных стержней. Магн. свойства С. были экспериментально изучены Ампером в 1822 (тогда же им был введён и термин «С.»), была установлена эквивалентность С. постоянным природным магнитам той же конфигурация, что явилось подтверждением электродинамич. теории Ампера, объясняющей магнетизм взаимодействием скрытых в телах кольцевых молекулярных токов.

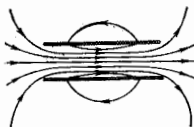
Энергия магн. поля С. с точностью до величины порядка d/l сосредоточена внутри С. Вдали от концов С. внутр. поле близко к однородному с напряжённостью $H = nI$ в СИ (в гауссовой системе единиц $H = 4\pi nI/c$). Внеш. поле С. близко к полю двух магн. зарядов $\pm q^m$, помещённых на его концах [$q^m = \mu_0 n^2 l d^2 / 2$ (μ_0 — магн. постоянная) в СИ, $q^m = \mu_0 n^2 l d^2 / c$ в гауссовой системе единиц]. Силовые линии магн. поля С. приведены на рис.

С. используются в физике и технике для создания квазигомогенных магн. полей и в качестве индуктивных элементов токовых цепей. С. с ферромагн. сердечниками применяются в качестве электромагнитов.

Лит.: Калантаров П. Л., Петляев Л. А., Расчет индуктивности, 3 изд., Л., 1968; Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, пер. с англ., т. 1, 5, 2 изд., М., 1977. Г. В. Перышкин. **СОЛИТОН** (от лат. solus — один) — локализованное стационарное или стационарное в среднем возмущение однородной или пространственно-периодич. нелинейной среды.

С. характеризуется следующими свойствами: локализован в конечной области; распространяется без деформации, переносит энергию, импульс, момент импульса; сохраняет свою структуру при взаимодействии с другими же С.; может образовывать связанные состояния, ансамбли. Профиль (форма) С. определяется в нелинейной среде двумя конкурирующими процессами: распыливанием волны из-за дисперсии среды и «прокидыванием» нарастающего волнового фронта из-за нелинейности.

До нач. 1960-х гг. С. называли уединённую волну — волновой пакет неизменной формы, распространяющийся с пост. скоростью по поверхности тяжёлой жидкости конечной глубины и в плазме. Ныне под определением С. полагает множество разнообразных физ. объектов. Первая классификация С. может быть сделана по числу пространственных измерений, вдоль к-рых происходит локализация стационарного возмущения нелинейной среды. К о д н о м е р н ы м С. относятся классич. уединённые волны в жидкостях, доменные стенки в ферро- и антиферромагнетиках, 2л-импульсы и солитоны отблещающей в нелинейной оптике (см. **Солитоны оптич. квант.**), локализов. моды коллективной проводимости в молекулярных органич. полупроводниках и в одномерных металлах (см. **Волны зарядовой плотности**), С. (кванты магн. потока) в джозефсоновских контактах в сверхпроводниках (см. **Джозефсоновский эффект**) и т. д. К д в у м е р н ы м С. относят дислокации в кристаллич. решётке, дискликации в жидких



кристаллах, вихревые структуры в толстом слое сверхтекучей жидкости, особенно разнообразные в сверхтекучем He^3 (см. *Сверстечность*), магн. трубки (вихри Абрикосова) в сверхпроводниках 2-го рода (см. *Сверстечность*), антициклональные области в геофиз. гидродинамике, в т. ч. «Большое красное пятно» на Юпитере, каналы *самоорганизации* в нелинейной оптике. Трёхмерные S . — это торондальные вихревые структуры в ферромагнетиках и толстом слое сверхтекучего He^3 , солитонные модели элементарных частиц (см. *Солитон* в квантовой теории поля), *чёрные дыры* в теории гравитации. В квантовой теории поля рассматривают S ., локализованные в четырёхмерном пространстве-времени, — *инстантоны*.

Математически S . представляют собой локализованные стационарные решения нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных или их обобщений (дифференциально-разностных, интегро-дифференциальных и т. п. ур-ний). Во мн. случаях разл. физ. ситуации и явления описываются одними и теми же ур-ниями, напр. *Кортвега — де Фриса уравнение*, *синус-Гордона уравнение*, *Шрёдингера уравнение* нелинейным, *Кадомацуэ — Петвиашвили уравнение*. Личные ур-ния (кроме одномерного волнового ур-ния) не имеют локализованных стационарных решений. S . представляют собой существенно нелинейные объекты, поведение и свойства k -рых принципиально отличаются от поведения волновых пакетов малой амплитуды. Различие особенно сильно, если S . обладает *топологическим зарядом*, т. е. если конфигурация волнового поля в присутствии S . топологически отлична от конфигурации невозмущённого состояния. Значит. часть ур-ний, имеющих солитонные решения, принадлежит к классу ур-ний, в k -ром применим *обратной задачи рассеяния метод*, большинство из них являются интегрируемыми гамилтоновыми системами.

Одномерные солитоны. Уединённая волна на поверхности жидкости конечной глубины впервые наблюдалась в 1834 Дж. С. Расселлом (J. S. Russell). Матем. выражение для формы этой волны было получено в 1854 Ж. В. Буассином (J. V. Boussinesq):

$$h = H + \frac{4Hx^2}{\text{ch}^2[(\kappa/H)x - (1+6\kappa^2)t - x_0]} \quad (1)$$

Здесь H — невозмущённая глубина жидкости, $v = \sqrt{gH}$ — скорость длинных волн малой амплитуды, x_0 — положение центра S ., $\kappa > 0$ — безразмерный параметр, характеризующий амплитуду, размер и скорость S . Ур-ние для одномерного S . было выведено в 1895 Кортвегом и де Фрисом. В холодной замагниченной плазме и в плазме без магн. поля с горячими электронами также могут распространяться удивительные волны, аналогичные S . на поверхности жидкости (Р. Э. Сагдеев, 1957). S . были использованы Р. Э. Сагдеевым при построении теории *вестмажонительных ударных волн* в плазме, возникающих, напр., при обтекании Земли солнечным ветром.

Моделируя на ЗВМ поведение цепочки атомов, связанных нелинейными упругими силами и описываемых ур-ниями движения

$$\ddot{x}_n = F(x_{n+1} - x_n) - F(x_n - x_{n-1}), \quad (2)$$

где $F(\xi) = \xi + d\xi^3 + \dots$, n — номер атома в цепочке, Э. Ферми (E. Fermi), Дж. Паста (J. Pasta) и С. Улам (S. Ulam) в 1954 обнаружили аномально медленную стохастизацию в этой системе. Система не термализовалась (в ней не устанавливалась термодинам. равновесие), а периодически возвращалась в исходное состояние с нач. распределением. При исследовании этой проблемы выяснилось, что в непрерывном пределе она переходит в Кортвега — де Фриса ур-ние (КДФ)

$$u_t + 6u_x u + u_{xxx} = 0, \quad (3)$$

выведенное в 1895 для описания эволюции волнового пакета на поверхности жидкости малой глубины. Ур-ние КДФ является универсальным ур-нием, описывающим одномерные или квазиодномерные среды, в k -рых конкурируют слабая квадратичная нелинейность (член $6u_x u$ в ур-нии (3)) и слабая линейная дисперсия (член u_{xxx} в ур-нии (3)). Оказалось, что оно описывает также и колебл. поведение цепочки атомов, а в пределе малой амплитуды и большой длины волны имеет солитонное решение:

$$u = \frac{2\kappa}{\text{ch}^2[\kappa(x - 4\kappa^2 t - x_0)]} \quad (4)$$

В зависимости от соотношения указанных выше двух факторов система переходит из одного состояния в другое, а в случае их взаимной компенсации возникает S .

Из численного решения ур-ния (3) [Н. Забуски (N. Zabusky) и М. Крускал (M. Kruskal), 1964] следует, что S . обладают значит. устойчивостью и при столкновениях рассеиваются упруго, сохраняя свою форму и амплитуду. Анализируя это явление, М. Крускал, Дж. Грин (G. Green), Ч. Гарднер (C. Gardner) и Р. Миура (R. Miura) открыли в 1967 фундамент. метод обратной задачи рассеяния, позволивший либо проинтегрировать ур-ние (3), k -рое можно представить как условие совместности переопределённой системы линейных ур-ний для вспомог. ф-ции Ψ :

$$\Psi_{xx} + (\lambda^2 + u)\Psi = 0, \quad (5)$$

$$\Psi_t = 4\Psi_{xxx} + 6u\Psi_x + 3u_x\Psi. \quad (6)$$

Ур-ние (5) представляет собой стационарное ур-ние Шрёдингера с потенциалом $-u(x,t)$. Если потенциал удовлетворяет ур-нию КДФ (3), то дискретные собств. значения ур-ния Шрёдингера не зависят от времени и непосредственно связаны с S . Если ур-ние (5) имеет N дискретных собств. значений $\lambda_n^2 = -\kappa_n^2$ ($n = 1, \dots, N$), то при $t \rightarrow \pm \infty$ будут присутствовать N S . вида (4) с параметрами $\kappa = \kappa_n$. В общем случае в решении содержится также осциллирующая «несолитонная часть».

Решение ур-ния (5), определённое методом обратной задачи рассеяния, имеет вид:

$$\Psi \rightarrow \exp(i\lambda x) + r(\lambda, t) \exp(-i\lambda x) \text{ при } x \rightarrow +\infty,$$

$$\Psi \rightarrow a^{-1}(\lambda) \exp(i\lambda x) \text{ при } x \rightarrow -\infty.$$

В чисто солитонном случае $r(\lambda, t) \equiv 0$

$$a(\lambda) = \prod_{n=1}^N \frac{(\lambda - i\kappa_n)}{(\lambda - i\kappa_n)}.$$

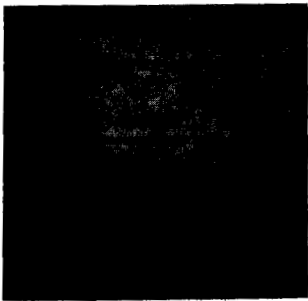
N -солитонное решение описывает рассеяние N S . друг на друге. Это рассеяние происходит упруго с сохранением амплитуд κ , сдвигаются лишь асимптотич. координаты S . При n -м столкновении S . с амплитудами κ_1, κ_2 ($\kappa_1 > \kappa_2$) S . приобретают сдвиги

$$(\Delta x_0)_1 = \frac{1}{2\kappa_1} \ln \frac{(\kappa_1 + \kappa_2)^2}{(\kappa_1 - \kappa_2)^2}, \quad (\Delta x_0)_2 = -\frac{\kappa_1}{\kappa_2} (\Delta x_0)_1,$$

т. е. быстрый S . приобретает положительный, а медленный — отрицательный сдвиги. При взаимодействии N S . полный сдвиг каждого S . равен алгебраич. сумме сдвигов от парных соударений, т. е. отсутствуют многосолитонные взаимодействия. Столкновения S ., описываемых ур-ниями КДФ, можно наглядно представлять как взаимодействие нерелятивистских частиц, между k -рыми действуют парные силы отталкивания. Напр., для двух S . (4) с одинаковыми амплитудами κ , разделённых расстоянием L , много бльшим характерного

размера $C \sim \kappa^{-1}$, потенциал силы отталкивания $U(L) \sim \kappa^2 \exp(-2\kappa L)$.

Типичная картина возникновения C в океане, сфотографированная из космоса, изображена на рис.:



чётко видны пять полос (солитонов), перемещающихся снизу справа вверх налево.

Шрёдингера и линейное уравнение для комплексной функции $u(x,t)$

$$iu_t + u_{xx} \pm 2|u|^2 u = 0 \quad (7)$$

является одним из осн. уравнений нелинейной физики, описывающим эволюцию оптич. волн в нелинейных кристаллах, ленгмювских волн в плазме, тепловых волн в твёрдых телах и др. При распространении одномерных квазиимпульсов волн в слабонелинейных средах в результате кубичной нелинейности (член u_{xx}) и линейной дисперсии (член $2|u|^2 u$) происходит самоудуление — величина волн огибающей. В случае равновесия нелинейного самосжатия и дисперсионного расплывания появляются C . огибающей. В случае знака \pm в уравн. (7) C . огибающая имеет вид:

$$u = 2i\eta \exp\left[\frac{1}{2}ivx + i\left(4\eta^2 - \frac{1}{4}v^2\right)t - i\Phi_0\right] \times \text{sech}[2\eta(x-vt-x_0)]. \quad (8)$$

Здесь η и v — амплитуда и скорость C . [в отличие от C . (4), эти параметры являются взаимно независимыми], Φ_0 и x_0 описывают фазу и положение C в нач. момент.

В. Е. Захаров и А. Б. Шабат показали (1971), что уравн. (7) также является точно интегрируемым в рамках метода обратной задачи рассеяния с помощью вспомогат. переопределённой системы линейных уравн. типа (5), (6) для многокомпонентной (векторной) функции Ψ . Следствием точной интегрируемости является наличие точных многосолитонных решений. Как и в случае уравн. КдФ, эти решения описывают чисто упругие столкновения C с сохранением формы, амплитуды и скорости. Единств. следствием столкновения являются фазовые сдвиги — изменения параметров Φ_0 и x_0 .

Одномерное уравн. нелинейное уравн. Шрёдингера. Точно интегрируемым с помощью вспомогат. линейных уравн. типа (5), (6) для векторной функции Ψ является также уравн. Шрёдингера —

$$\Phi_{tt} - \Phi_{xx} \pm \sin\Phi = 0. \quad (9)$$

Это уравн. встречается во мн. физ. задачах, в n -ых ангармонич. потенциал нелинейного самовоздействия волнового поля периодич. по полевой переменн. $\Phi(x,t)$. Примерами являются длинные волны в джоузефовских переходах, волн зарядовой плотности в одномерных металлах, нелинейные волны намагни-

ченности в легкоплоскостных и слабых ферромагнетиках и т. д.

Уравн. (9) имеет солитонные решения двух разл. типов: т. н. кинки и бризеры. Кинки

$$\Phi_K = \arctg[\exp(\sigma(x-vt-x_0)(1-v^2)^{-1/4})] \quad (10)$$

представляет собой единичную волну, обладающую топологич. зарядом $(2\pi)^{-1}(\Phi_K(x \rightarrow \infty) - \Phi_K(x \rightarrow -\infty)) \equiv \sigma$, движущуюся со скоростью v ($v^2 < 1$). Кинка имеет смысл т. н. флуксона — кванта магн. потока в теории длинных джоузефовских переходов, доменной стенки — в ферромагнетиках, носителя заряда — в одномерных металлах и т. д. Точные решения уравн. (9) описывают чисто упругие столкновения любого числа кинков (10), сопровождающиеся фазовыми сдвигами, т. е. изменением параметров x_0 , характеризующих положение кинков в нач. момент. В частности, при столкновении двух кинков со скоростями v_1, v_2 ($v_1 > v_2$) фазовые сдвиги равны:

$$(\Delta x_0)_1 = 2\sqrt{1-v_1^2} \ln \frac{\sqrt{(1+v_1)(1-v_2)} + \sqrt{(1+v_2)(1-v_1)}}{\sqrt{(1+v_1)(1-v_1)} - \sqrt{(1+v_2)(1-v_2)}},$$

$$(\Delta x_0)_2 = -\sqrt{(1-v_2^2)} / \sqrt{(1-v_1^2)} (\Delta x_0)_1.$$

Видно, что фазовые сдвиги не зависят от топологии зарядов кинков.

Как и для C ., описываемых уравн. (3) и (7), полный фазовый сдвиг любого кинка при рассеянии на совокупности остальных кинков в точности равен сумме сдвигов, порождённых его столкновениями с каждым из остальных кинков по отдельности.

Наглядно два кинка, разделённых расстоянием L , много больше их характерных размеров $\sim (1-v^2)^{-1/2}$, можно представлять как две релятивистские частицы, взаимодействующие с потенциалом $U(L) \sim \sigma_1 \exp(-L)$. Т. о., кинки с одинаковыми зарядами $\sigma_1 = \sigma_2$ отталкиваются, с противоположными ($\sigma_1 = -\sigma_2$) — притягиваются.

Пара кинков с противоположными зарядами может образоват. связанное осциллирующее состояние — т. н. бр и в е р, представляющий собой 2-й тип точного солитонного решения уравн. (9):

$$\Phi_{br} = 4\arctg\{t\text{g}\cos\{(t-t_0)\cos\mu\} \text{sech}(x-x_0)\sin\mu\} \quad (11)$$

[движущийся бризер может быть получен из (11) преобразованием Лоренца]. Параметр μ , изменяющийся в пределах $0 < \mu < \pi/2$, характеризует энергию связи бризера, определённую разность энергий пары удалённых покоящихся ($v=0$) кинков (10) и энергии бризера (11): $\mathcal{E} = 32\sin^2(\mu/2)$. Столкновения бризеров друг с другом и с кинками также являются чисто упругими и сопровождаются аддитивными фазовыми сдвигами. В реальных системах бризер не наблюдается вследствие диссипации.

В пределе $\Phi^2 \ll 1$ подстановка

$$\Phi(x,t) = u(x,t)\exp(-it) + u^*(x,t)\exp(it)$$

преобразует уравн. (9) в нелинейное уравн. Шрёдингера (7) (с верх. знаком). При этом бризер (11) (при $\mu < \pi/2$) преобразуется в покоящийся C . (8) с амплитудой $\eta = \mu$.

Многомерные солитоны. Двумерный C является решением точно интегрируемого уравн. Кадомова — Петвиашвили

$$\frac{\partial}{\partial x^2}(u_t - bu_x - u_{xx}) = -3uu_x, \quad (12)$$

описывающего ионно-звуковые волны в плазме, капиллярные волны на поверхности «мелкой» жидкости и т. д. Точное решение уравн. (12)

$$u(x,y,t) = 2 \frac{\partial}{\partial x^2} \ln [4(v+y^2)^{-2} + |x-iy-3v^2t|^2], \quad (13)$$

описывает произвольный комплексный параметр ψ , описывает устойчивый двумерный С. (т. н. ламы), движущийся со скоростью $v = (v_x, v_y)$, $v_x = 3|v|^2$, $v_y = -6|v|v$. При $(x^2 + y^2) \rightarrow \infty$ решение (13) убывает как $(x^2 + y^2)^{-1}$, т. е., в отличие от одномерных С. (4), (8), (10), (11), характеризующихся экспоненциальным спадом профиля при $|x| \rightarrow \infty$, двумерный С. (13) имеет степенную асимптотику. Столкновения любого числа лампов (13) являются чисто упругими, причём, в отличие от одномерных С., фазовые сдвиги тождественно равны нулю.

Попытке С. можно обобщить и на случай неинтегрируемых нелинейных волновых ур-ний. Сюда можно отнести почти интегрируемые системы, отличающиеся от универсальных интегрируемых ур-ний малыми возмущающими членами, что имеет место в реальных физ. системах. Теория возмущений для почти интегрируемых систем также основана на методе обратной задачи рассеяния [Д. Кауп (D. Kaup), 1976; В. И. Карпман и Е. М. Маслов, 1977]. В почти интегрируемых системах динамика С. более богата; в частности, малые возмущения могут породить неупругие взаимодействия С. и многосолитонные эффекты, отсутствующие в точно интегрируемом случае.

В системах, далёких от точно интегрируемых, взаимодействия С. оказываются глубоко неупругими. Так, неинтегрируемое релятивистски инвариантное волновое ур-ние

$$\Phi_{tt} - \Phi_{xx} - \frac{1}{2}\Phi + \frac{1}{2}\Phi^3 = 0,$$

описывающее, напр., динамику параметра порядка при фазовых переходах типа смещения в сегнетоэлектриках, имеет точное устойчивое решение типа киника:

$$\Phi_{tt} = \text{th} \left[-\frac{\sigma}{2}(x-vt)(1-v^2)^{-1/2} \right], \quad \sigma = \pm 1. \quad (14)$$

Численное исследование показывает, что столкновения двух киников (14) с разл. топологич. зарядом σ может приводить к аннигиляции этих С. в квазипериодические волны (излучение).

Примером С. в неинтегрируемой трёхмерной системе является т. н. скирмион — солитон *Скирма модели*, хорошо описывающей знаменитую динамику куклонов.

Нелинейное ур-ние Шрёдингера более общего вида, чем (7),

$$i\psi_t + \Delta\psi + |\psi|^{2n}\psi = 0, \quad (15)$$

где Δ — Лапласа оператор, действующий в пространстве произвольной размерности D , а n — произвольное положит. число, также может иметь солитонное решение (это ур-ние интегрируемо лишь в случае $n = 1$, $D = 1$). Такой С. может быть устойчив лишь при $nD < 2$; в обратном случае он оказывается неустойчивым относительно волнового коллапса (см. Солитон в плазме).

Лит.: Ребб и К., Солитоны, пер. с англ., «УФН», 1980, т. 130, в. 2, с. 329; Теория солитонов. Метод обратной задачи, М., 1980; Солитоны, под ред. К. Лонгрина, Ф. Скотта, пер. с англ., М., 1981; Ли м Д ж. Ли, Введение в теорию солитонов, пер. с англ., М., 1983; Солитоны, под ред. Р. Будлафа, Ф. Коппа, пер. с англ., М., 1983; Россевич А. М., Фадеев В. А., Ковалев А. С., Нелинейные волны и магнитичности. Динамические и топологические солитоны, К., 1983; Давыдов А. С., Солитоны в молекулярных системах, К., 1984; Квалонд жеро Ф., Дегат ери с А. С., Спектральные преобразования в действиях. Методы решения и исследования нелинейных эволюционных уравнений, пер. с англ., М., 1985; Раджараман Р., Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля, пер. с англ., М., 1985; Тавтаджян Л. А., Фадеев В. А., Гамкельзон подход в теории солитонов, М., 1986; Абдуллаев Ф. Х., Абабидов П. К., Динамика солитонов в неоднородных конденсированных средах, Таш., 1986; Филиппов А. Т., Многосолитный солитон, М., 1986; Абрахам М. Дж., Солитоны, пер. с англ., М., 1987; Solitons, ed. by S. E. Trullinger, V. E. Zakharov, V. L. Pokrovsky, Amst., 1986; Kiv & Yang Yu. S. A. & M. J. Ablowitz, Dynamics of solitons in nearly integrable systems, «Физ. Физур», 1989, ч. 61, в. 7, с. 763.

В. Е. Захаров, В. А. Маламод,

СОЛИТОН в квантовой теории, поля — устойчивое нетриантное классич. решение ур-ний кантовой теории поля. Такой объект изучают с нач. 1970-х гг., когда среди решений ур-ний, инвариантных относительно Лоренца преобразований, были найдены С. Причём формулы сформулированы Гурдона вращении и нелинейное волновое ур-ние Клейна — Гордона для скалярного поля ϕ

$$\Phi_{tt} - \Phi_{xx} - \Phi + \Phi^3 = 0 \quad (1)$$

(см. Солитон). Здесь Φ и Φ_{xx} — вторые производные соответственно по времени и по координате. Энергия \mathcal{E} и импульс \mathcal{P} , соответствующие таким солитонным решениям, связаны соотношением $\mathcal{E}^2 = \mathcal{P}^2 + M_c^2$ (здесь и далее полагается $c = 1$), где M_c — масса или энергия С. в состоянии покоя. Исследование процессов рассеяния классических С. указывает на их сходство с аналогич. процессами в физике элементарных частиц — адронов.

Формально в квантовой теории поля С. появляются как решения, обеспечивающие наименьшие минимумы действия. Интегральный подход к С. требует проведения процедуры квантования флуктуаций вокруг классич. решений (квантокласич. приближение). При этом возникает проблема квантования нулевых мод, т. е. полевых конфигураций, возникающих при всевозможных трансляциях, поворотах и др. преобразованиях над солитонными решениями, при к-рых не изменяется энергия С. В отличие от ненулевых, нулевые моды не являются малыми отклонениями от классич. солитонного решения и должны быть учтены точно. Процедура квантования с учётом нулевых мод состоит в применении метода коллективных координат для получения хорошо определённого функционального интеграла (интеграла по путям) в пространстве полевых конфигураций.

Для нек-рых вполне интегрируемых ур-ний, напр. для ур-ния синус-Гордона, удаётся получить точное квантовое решение для матрицы рассеяния (S -матрицы) С. При этом, как и в классич. теории, для таких систем взаимодействие С. не приводит к дополнит. рождению частиц, т. е. является упругим, а S -матрица многочастичных процессов обладает свойством факторизуемости, т. е. представима в виде произведений S -матриц различных парных процессов.

С. в квантовой теории поля можно разделить на два класса — топологические солитоны и нетопологические. Среди топологич. С. (устойчивые к-рых определяется существованием нек-рых квантовых чисел — топологических зарядов, связанных с глобальными характеристиками решений) следует отметить С. типа «ёж». Так, для эффективной киральной (см. Киральная симметрия) теории л-мезонного поля с лагранжианом

$$L = \frac{F_\pi^2}{16} \text{Tr}(\partial_\mu U + \partial_\mu U^\dagger)^2 + \frac{1}{32e^2} \text{Tr}(U^\dagger \partial_\mu U, U^\dagger \partial_\mu U)^2, \quad (2)$$

где U — унитарная матрица 2×2 , F_π и e — параметры теории, существует солитонное решение типа «ёж» (скирмион) $U = \exp(i\hat{f}(r)\hat{n})$, где $\hat{n} = \mathbf{r}/r$ (r — координата), \hat{f} — Паули матрицы и $\hat{f}(r)$ — ф-ция, определяемая ур-ниями движения с граничными значениями, подчиняющимися условию целочисленности величин $B = [f(0) - f(\infty)]/\pi$, $B = 0, +1, +2, \dots$, являющейся топологич. зарядом (см. также Скирма модель). Значение B при этом отождествляется с барионным числом. Имеются аргументы в пользу того, что квантовый скирмион, построенный на основе ур-ния (1) для бозонных полей, может быть фермионом, т. е. подчиняться статистике Ферми — Дирака. Заметим, что в теории скалярного поля, подчиняющегося ур-нию синус-Гордона, оператор солитонного поля также является фермионским, т. е. подчиняется антикоммутац.

соотношениям. Квантование вращат. нулевых мод скирмиона позволило удовлетворительно описать статист. свойства нуклона и первого возбужденного нуклонного резонанса $\Delta(1232)^{3/2}_2$, а также фазы пикнону-клионного рассеяния.

Средя др. топологич. солитонных решений следует отметить решение т'Хоофта — Полякова (G. 'tHooft, 1974; A. M. Polyakov, 1974), и-рое возникает в простейшем случае как решение с конечной энергией в системе $SU(2)$ -триплетта вестественных скалярных полей и триплетта векторных калибровочных полей. Подобные классич. магнитные монополи существуют и в моделях *веклого обобщения*, основанных на группах $SU(5)$, $SU(10)$ и др. При этом массы монополей велики и составляют примерно 10^{16} — 10^{17} гэВ. Учёт квантовых поправок уменьшает величину массы монополя по сравнению с его классич. значением.

В нек-рых теориях поля существуют нетопологические С., т. е. С. с граничными условиями, эквивалентными вакуумной конфигурации полей. Такие С. получили назв. *Q-б-о-л-о-в*. Квантовае Q-б-оллы могут проявлять себя на опыте как тядёные заряд. скалярные частицы.

В квантовой теории поля наряду с С. локально минимизирующим действие в пространстве Минковского, часто рассматриваются решения, минимизирующие действие в евклидовом пространстве. Получающиеся при этом солитонные решения наз. *инстантонами* и бау-и с а м и. Под инстантоном обычно понимают классич. решение в евклидовом пространстве, отвечающее подбарьерной траектории в пространстве полей, соединяющее между собой вырожденные вакуумные состояния. При этом действие S_E , подсчитанное для инстантонного решения с учётом квантовых поправок, определяет вероятность w перехода из одного вакуумного состояния в другое, $w = \text{Aexp}(-S_E)$. При наличии неск. невырожденных вакуумных состояний часто возникает вопрос о распаде состояний, первоначально находящихся в ложном вакууме (т. е. в вакууме с минимальной энергией). Процедура определения вероятности таких распадов связана с поиском С. евклидова действия, соединяющего классич. решение, отвечающее ложному вакууму, с классич. решением той же энергии, расположенным над истинным вакуумом. Такое решение наз. бау-сом.

Дум.: 'tHooft G., Magnetic monopoles in unified gauge theories, *Nucl. Phys.*, 1974, v. B79, p. 276; Поляков А. М., Спентр частиц в квантовой теории поля, «Письма в ЖЭТФ», 1974, т. 20, с. 430; Вейля и Лип А. А. и др., *Resonant solutions of the Yang — Mills equations*, *Phys. Lett.*, 1975, v. 52B, p. 85; Neven A., *Quantization of nonlinear systems*, *Repts Progr. Phys.*, 1977, v. 40, p. 709; Ожун Л. Б., Физика элементарных частиц, 2 изд., М., 1986; Радрикс Р. А. и др., *Solitons and instantons in quantum theory of fields*, пер. с англ., Солитон, 1985.

СОЛНИТОН в плазме — удельная волна, возникающая в результате развития в плазме сильнонелинейных процессов и устойчиво существующая в ней. Наиб. важными и хорошо научными являются дватна С.: ионно-звуковые С. в неизотермич. плазме и ленгмюровские (электронные) С. в холодной плазме.

Ионно-звуковые солитоны. Нелинейность ионно-звуковых волн (см. *Волны в плазме*) описывается конвективным членом в гидродинамич. ур-ниях движения холодной плазмы. В простейшем случае однорядной бесстолкновительной неизотермич. плазмы (т. е. при условии $T_e \gg T_i$, где T_e и T_i — темп-ры электронов и ионов) в отсутствие магн. поля неллинейные ионно-звуковые волны описываются *Кортвега — де Фриса уравнением* (КдФ)

$$n_t + \beta n n_x + n_{xxx} = 0, \quad (1)$$

где переменная величина n может рассматриваться как возмущение плотности ионов; электрич. потенциал и ср. скорость движения ионов также пропорциональны n . Ур-ние (1) имеет хорошо известное устойчивое решение в виде С.

$$n_{sol} = 2\kappa^2 \text{sech}^2 \kappa(x - 4\kappa^2 t) \quad (2)$$

(κ — его произвольная амплитуда), движущегося со скоростью $v = 4\kappa^2$. Физически С. (2) соответствует области сжатия (повыш. плотности плазмы), перемежающейся с пол. скоростью в квазиодномерной плазме.

К тому же виду (1) сводится ур-ние для неллинейных магнито-звуковых волн в плазме, помещённой во внеш. магн. поле; т. е. ур-ние КдФ модерирует также распространение магнито-звуковых плазменных С. Ионно-звуковые С. в плазме экспериментально обнаружены в нач. 1970-х гг. [1].

В двумерном случае естеств. обобщением ур-ния КдФ является *Кадомотца — Петвиашвили уравнение* (КП):

$$\frac{\partial}{\partial x} (n_t + \beta n n_x + n_{xxx}) = \pm n_{yy}. \quad (3)$$

Ионно-звуковые волны в двумерной плазме обладают отрицат. дисперсией, что соответствует знаку «минус» в правой части ур-ния (3). Ур-ние КП для них имеет устойчивые решения в виде косых (под нек-рым углом к магн. полю) квазиодномерных С. вида:

$$n_{sol} = 2\kappa^2 \text{sech}^2 \kappa(x + ky) - (4\kappa^2 + k^2) t, \quad (4)$$

где параметр k определяет ориентацию С.

Ур-ние КП со знаком «плюс» описывает распространение магнито-звуковых волн с положит. дисперсией в холодной замагниченной плазме под углом к магн. полю. При этом предполагается, что частота магнито-звуковых волн много меньше циклотронной частоты. Решения квазиодномерных магнито-звуковых С. вида (2) неустойчивы, однако в двумерном случае есть устойчивые решение в виде т. н. *лампы* (*lumps*) — движущихся и локализованных по всем направлениям двумерных С. В отличие от квазиодномерных С. (4), лампы характеризуются не экспоненциальным, а степенным убыванием на бесконечности:

$$u(x, y) \sim (x^2 + y^2)^{-1} \text{ при } x^2 + y^2 \rightarrow \infty.$$

Ленгмюровские солитоны. Образование ленгмюровских С. в холодной плазме возможно благодаря действию поперечноторных сил, выталкивающих плазму из области с повыш. напряжённостью электрич. поля. В этом случае может возникнуть С. в виде т. н. *кавиты* и т. н. *а-локалов*. области с повыш. значением электрич. поля и пониж. плотностью плазмы. Эволюция комплекснойгибающей $u(x, t)$ ленгмюровских волн в однорядной холодной квазиодномерной плазме описывается *Шрёдингера уравнением нелинейнж* (ШУ)

$$i u_t + u_{xx} + 2|u|^2 u = 0. \quad (5)$$

Устойчивое солитонное решение ур-ния (5) имеет вид:

$$u = 2\eta \text{sech}[2\eta(x - vt)] \exp[i(vx - t + (4\eta^2 - v^2/4)t)], \quad (6)$$

где η и v — произвольные параметры, задающие амплитуду и скорость С. Плазменные кавитоны, описываемые (6), обнаружены экспериментально в 1974—75.

Квазиодномерные ленгмюровские С. оказываются устойчивыми в двух- и трёхмерных случаях. Развитие этой неустойчивости приводит в конечном счёте к ленгмюровскому *волновому коллапсу*.

Взаимодействие ленгмюровских и ионно-звуковых волн [или, в матем. терминах, взаимодействие комплекснойгибающей $u(x, t)$ ленгмюровских волн с вещественным возмущением плотности плазмы $n(x, t)$] описывается системой ур-ний Захарова:

$$\begin{aligned} i u_t + u_{xx} + 2nu &= 0, \\ n_t - n_{xx} &= -(|u|^2)_{xx}. \end{aligned} \quad (7)$$

При $u = 0$ система ур-ний (7) переходит в линейное волновое ур-ние для ионно-звуковых волн. Эта система имеет точное устойчивое решение, соответствующее ленгмюровскому С. в однорядном случае и устойчивое — для двух- и трёхмерных обобщений [2].

Взаимодействия солитонов в плазме могут быть как упругими, так и неупругими. Упругие взаимодействия с полным сохранением структуры С. при столкновении описываются точно интегрируемыми ур-ниями КдФ, КП и ШУН (см. *Обратной задачи рассеяния метод*). Неинтегрируемая система ур-ний Захарова описывает неупругие столкновения С., приводящие к интенсивному излучению линейных волн, слиянию сталкивающихся С. в новый С. и т. д. Неупругими оказываются также взаимодействия С. со свободными ионно-звуковыми волнами. Напр., монохроматическое дробное звуковое колебание, воздействующее на ленгмюровский С., приводит к его распаду на линейные ленгмюровские волны. Описание реальной плазмы, основанное на ур-ниях КдФ, КП и ШУН, является сильно идеализованным. Часто необходимо учитывать доплит. эффекты, к-рые могут существенно влиять на динамику С. в плазме. Это даёт доплит. (возмущающие) члены в указанных ур-ниях. В том случае для анализа динамики С. используется теория возмущений. Так, напр., при учёте конечности отношения T_i/T_e ионно-звуковые С. в неизоэнтальп. бестолкновительной плазме распадаются вследствие *Landau затухания*. С учётом этого эффекта ур-ние КдФ (1) превращается в ур-ние КдФ — Бюргерса

$$n_t + \beta n n_x + n_{xxx} = \alpha n n_x \quad (8)$$

с положит. диссипативным параметром α . Вместо солитонных решений ур-ние (8) имеет решение в виде устойчивой движущейся волны перепада плотности с коэлат. структурой — *бестолкновительной ударной волны*.

Для ленгмюровских С. важно взаимодействие с электронами плазмы, также приводящее к затуханию Ландау. Возмущающим фактором для ленгмюровского С. является также неоднородность плазмы: он притягивается областью плазмы, где плотность понижена, и может совершать колебания вблизи минимума плотности.

В плазме могут встречаться и С. др. типов, напр. С. пиклоotronных волн, различные двумерные дрейфовые вихри [4] и С. в системе резонансно взаимодействующих простых волн.

Лит.: 1) Триан М. Q., Ion-acoustic soliton in a plasma. A review of their experimental. Properties and related theories, «Physica Scripta», 1979, v. 20, p. 317; 2) Захаров В. Е., Коплиц и самофокусировка ленгмюровских волн, в кн.: Основы физики плазмы, т. 2, М., 1984; 3) Kitvaha Y. U. S., M. A. I. o m e d B. A., Dynamics of solitons in nearly integrable systems, «Rev. Mod. Phys.», 1989, v. 61, p. 763; 4) Петляшвили В. И., П о х о т е л о в О. А., Уединенные волны в плазме и атмосфере, М., 1989; Основы физики плазмы, т. 1—2, М., 1983—84, Б. А. Маломей.

СОЛИТОНЫ оптически нелинейные — оптические импульсы, сохраняющие структурную устойчивость при распространении в нелинейной среде даже при наличии возмущающих факторов и взаимодействиях с др. С. В зависимости от характера нелинейного взаимодействия излучения с веществом солитонные эффекты в оптике разделяют на резонансные и нерезонансные.

В нерезонансных средах оптич. С. формируются в результате баланса двух конкурирующих процессов — дисперсионного, распыливания (см. *Дисперсия света*) и нелинейного саможатия (см. *Самовоздействие света*). Наиб. благоприятные условия для формирования С. реализуются в одномодовых волоконных световодах благодаря предельно малым потерям (~2,0 дБ/км) при длине волны излучения $\lambda = 1,55$ мкм) и устойчивости модовой структуры излучения при возрастании входной мощности вплоть до значений, близких к порогу самофокусировки.

Временные эффекты самовоздействия (саможатия) оптич. импульсов обусловлены нелинейной добавкой к показателю преломления $\delta n = n_2 I_{\text{эф}}$, где эфф. значение интенсивности $I_{\text{эф}} = P_0/S_{\text{эф}}$ определяется отношением пиковой мощности импульса P_0 к эфф. площади моды $S_{\text{эф}}$, n_2 — коэф. нелинейности (в кварцевых световодах $n_2 = 3,2 \cdot 10^{-16}$ см²/Вт). При распространении импульса на расстояние z его вершина приобретает доплит. фазовый набег $\delta\varphi = kn_2 I_{\text{эф}} z$ (k — волновое число) и, следовательно, зависящую от времени добавку к несущей частоте $\delta\omega = \partial(\delta\varphi)/\partial t$. Т. о., в результате фазовой самомодуляции нарастает несущая частота от фронта импульса к его хвосту, т. е. происходит частотная модуляция. Для скорости частотной модуляции $\alpha_{\text{фс}} = \partial(\delta\omega)/\partial t$ справедлива оценка $\alpha_{\text{фс}} \sim kn_2 I_{\text{эф}} z^2/\tau_p^2$, где τ_p — длительность импульса.

Другой конкурирующий процесс — дисперсионное распыливание импульса возникает вследствие дисперсии групповой скорости, характеризуемой величиной $k_z = \partial^2 k/\partial\omega^2$. Спектрально-ограниченный импульс приобретает частотную модуляцию, скорость к-рой $\alpha_d = 2\omega k_z'/(c^2 + L_D^{-2})$ зависит от пробегённого расстояния z , где $L_D = c^2/|k_z|$ — дисперсионная длина. В спектральном диапазоне, соответствующем аномальной дисперсии групповой скорости ($k_z < 0$, $\lambda > 1,3$ мкм), частота импульса уменьшается от фронта импульса к хвосту.

Из условия баланса конкурирующих процессов $\alpha_d + \alpha_{\text{фс}} = 0$ при прохождении импульсом расстояния $z \ll L_D$ можно оценить критич. мощность, при к-рой формируется С. $P_{\text{кр}} = k_p S_{\text{эф}}/(kn_2 \tau_p^2)$.

Основой для адекватного матем. описания процессов формирования и взаимодействия С. пикосекундного диапазона длительностью является нелинейное ур-ние Шрёдингера, к-рому удовлетворяет комплексная амплитуда поля $q(\xi, \tau)$ (см. *Солитоны*). Отбрасывая солитонного импульса имеет вид $q = \text{sech}(\tau) \exp(-i\xi/2)$, где ξ — расстояние, нормированное на дисперсионную длину L_D , $\tau = (t - z/u)/\tau_p$ — бегущее время, нормированное на нач. длительность импульса, u — групповая скорость. Нелинейное ур-ние Шрёдингера принадлежит к классу интегрируемых нелинейных ур-ний и

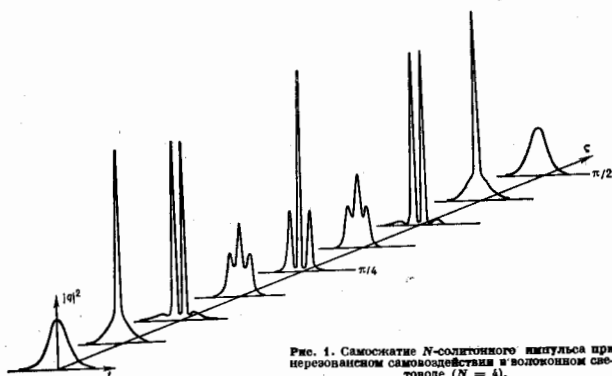


Рис. 1. Саможатие N -солитонного импульса при нерезонансном самовоздействии в волоконном световоде ($N = 4$).

решается *обратной задаче рассеяния методом*. Если мощность спектрально-ограниченного импульса превышает критическую, то его асимптотич. поведение при $\zeta \rightarrow \infty$ определяется солитонной составляющей, амплитуда несолитонной части решения убывает $\propto \zeta^{-1/2}$.

Важным классом аналитически вычисляемых решений нелинейного ур-ня Шрёдингера являются N -солитонные импульсы, соответствующие нач. условиям вида $q(0, \tau) = N \operatorname{sech} \tau$, где N — целое число. Они представляют собой нелинейную суперпозицию N движущихся с одинаковой скоростью солитонов с амплитудами $q_m = (2m - 1)$, $m = 1, 2, \dots, N$. Важные особенности N -солитонных импульсов состоят в том, что их распространение начинается с самосжатия (рис. 1), а модуль комплексной амплитуды периодичен по ζ с периодом $\pi/2$.

Закономерности формирования и распространения односолитонных и N -солитонных импульсов были подтверждены экспериментами Л. Молленауэра (L. Mollemauer), Р. Х. Столена (R. H. Stolen) и В. Гордона (W. Gordon). В этих опытах с помощью тщательно сформированных пикосекундных импульсов синхронно накачиваемого лазера на центрах окраски ($\lambda = 1,5$ мкм; полная длительность импульса по полувысоте — 7 пс; $P \approx 1 - 22$ Вт) удалось наблюдать односолитонные и N -солитонные импульсы для $N \leq 4$. Успешные эксперименты с С. стимулировали их применение в волоконной оптике, связи для сверхкороткой передачи информации, в технике формирования импульсов фемтосекундной длительности, в спектроскопии быстрорастекающих процессов и привели к созданию солитонных лазеров.

Теоретически и экспериментально исследовано влияние различных возмущающих факторов (оптика, потери, дисперсия высших порядков, инерционность нелинейного отклика, стохастич. возмущения формы входного импульса и параметров световода) на распространение пико- и фемтосекундных С. и на их взаимодействие. Показана возможность компенсации оптич. потерь за счёт комбинац. усиления, что позволяет реализовать передачу С. на расстоянии до 50 км.

Распространение мощных когерентных импульсов света в резонансно-поглощающих средах (см. *Самодиффракционная прозрачность*) также сопровождается солитонными эффектами. Если длительность импульса t_0 существенно меньше времени релаксации населенностей T_1 и затухания свободной поляризации T_2 , то в результате поглощения в течение 1-й половины импульса и последующего усиления в течение 2-й половины импульса формируется стационарный волновой пакет, проникающий в среду на расстояние, существенно превышающее длину линейного поглощения (см. также *Двууровневая система*).

Матем. описание этого процесса основывается на системе ур-ний Максвелла — Блоха. Для спектрально-ограниченных импульсов осн. значение имеет площадь, заключенная под огибающей:

$$S(t, z) = \kappa \int_{-\infty}^t A(t', z) dt,$$

где $\kappa = 2d/\hbar$, d — дипольный момент резонансного перехода, κ — постоянная Планка. Импульсы с площадью $S = 2\hbar$ и огибающей $A = 2(\kappa t_0)^{-1} \operatorname{sech}(t/t_0)$ являются устойчивыми. Групповая скорость распространения импульса и меньше скорости света. Характерное время задержки t_0 импульса на расстоянии L пропорционально коэф. линейного поглощения δ : $t_0 = L/(u^2 - c^2) = 8L/c\delta$. Если площадь исходящего импульса превышает $2\hbar$ в N раз, то в процессе распространения он распадается на последовательность N импульсов с разл. длительностями, амплитудами и скоростями (рис. 2).

Солитонные эффекты проявляются при взаимодействии волновых пакетов с разл. несущими частотами

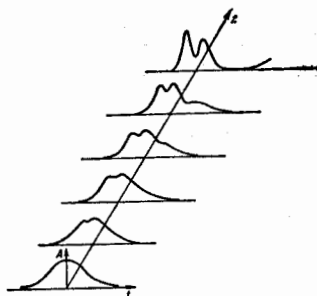


Рис. 2. Разбиение 8-импульса на три 2л-импульса при резонансном самодействии.

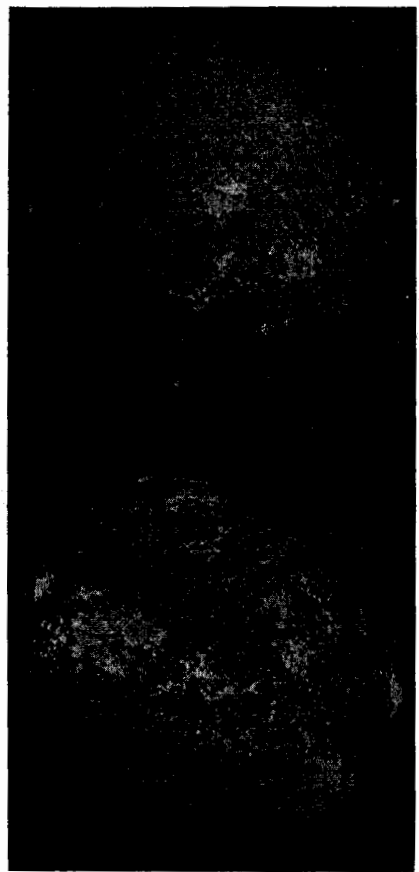
в средах с квадратичной нелинейностью (т. е. и параметрические С.). В этом случае стационарный импульс формируется в результате баланса процессов энергообмена и расстройки групповых скоростей. Теоретически показана возможность формирования С. при вынужденном комбинац. рассеянии света (ВКР-солитоны) и в процессе вынужденного *Мандельштама — Бриллюэна* рассеяния, однако экспериментально они не наблюдались из-за ряда жестких требований на параметры излучения и среды.

Лит.: Теория солитонов. Метод обратной задачи, М., 1980; Аллен Л., Эберли Д.ж., Оптический резонанс и двухуровневые атомы, пер. с англ., М., 1978; Ахманов С. А., Вихарев В. А., Чиркин А. С., Оптика фемтосекундных лазерных импульсов, М., 1988; Сухоручков А. П., Нелинейные волновые взаимодействия в оптике и радиопроцессах, М., 1988. С. А. Ахманов, В. А. Выхарев.

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ — в широком смысле — изменчивость (перемещенность) Солнца. Проявляется во всей совокупности нестационарных процессов на Солнце и в его атмосфере; возникновении и исчезновении пятен, протуберанцев, факелов, флюккул (рис. 1); возрастании УФ-, рентг. и радионалучения; *всплескам* на Солнце.

Все указанные проявления С. а., как правило, тесно связаны между собой и имеют место в т. н. активных областях, в к-рых выходят на поверхность сильные магн. поля. Это свидетельствует об общей природе проявлений С. а.: все они связаны с магн. полем Солнца. Поэтому под С. а. в узком смысле часто понимают почти периодич. перемещенность магн. поля Солнца. Последняя характеризуется неск. параметрами, или индексами, и в активности, важнейшими из к-рых являются числовые отношения: число солнечных пятен, или *Вольфа число*. Оно определяется по ф-ле $R_z = k(f + 10)g$, где f — общее число пятен на видимой полусфере Солнца, g — число групп пятен, k — коэф., позволяющий привести наблюдательные данные разл. наблюдателей и стандартной шкале солнечных чисел. Среднее за год широкое число, как и средние годовые числа др. активных явлений на Солнце, изменяется с периодом ок. 11 лет, что и наз. *цикл* С. а. или *солнечным циклом*. Ср. широта пятен также изменяется в ходе цикла: первые пятна цикла появляются около широт $\pm 30^\circ$, последние — гораздо ближе к солнечному экватору, около широт $\pm 5^\circ$. Это изменение (часто называемое *законом* Шпеллера) лучше всего иллюстрируется т. н. *диграммой* С. а. (рис. 2). Поскольку с пятнами связаны др. проявления С. а., напр. флюккулы и вспышки, их статистич. поведение также характеризуется 11-летним циклом и широтным распределением, подобным *абсолютному* Маундера.

Рис. 1. Фотографии Солнца в хромоферной линии С₁₁.
 Внизу область — хромоферная флюктуя. Вверху — активное
 Солнце, вверху — Солнце вблизи минимума активности.



При смене цикла С₁ а. меняется полярность общего магн. поля Солнца, а в группах пятен меняется полярность мелкого (≈ 2 -клеточного) поля. Поэтому правильно говорить о 22-клеточном цикле. Каждый цикл (п. п.) состоит из двух фаз: фаза активности и фаза неактивности. На время отравляющего действия магн. поля в хромоферной области (рис. 3). На время отравляющего действия магн. поля в хромоферной области (рис. 3). На время отравляющего действия магн. поля в хромоферной области (рис. 3).

Рис. 3. Вверху — сопоставление значений порогового числа R_p в 19-21-м циклах солнечной активности. Вертикальные линии показывают время начала цикла в хромоферной области. Внизу — схематическое изображение широтного поля активности. Внизу — схематическое изображение широтного поля активности. Внизу — схематическое изображение широтного поля активности.

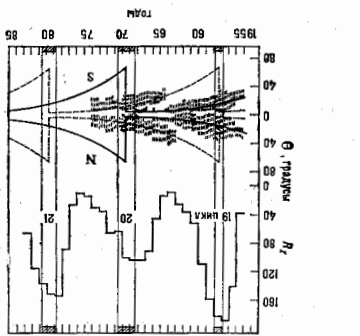
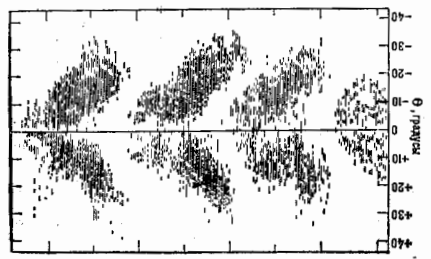


Рис. 2. Широтное распределение солнечных пятен с 1874 по 1910 (— широта). 1913 (— широта).



время образом вытекают из Уолтерсона, лавашки С. а. и, в частности, о существовании очень большого уровня С₁ а. в течение 70 лет начиная с 1645 (Г. и. Миним и М. А. Уайт). [1] Исследование и изменение магн. поля, обусловленные наблюдениями проваления С₁ а. — один из главных вопросов физики Солнца. Солнечные магн. явления на поверхности и в атмосфере и внутри Солнца происходят вместе с ней. Поэтому практически все явления на поверхности и в атмосфере и внутри Солнца происходят вместе с ней. Поэтому практически все явления на поверхности и в атмосфере и внутри Солнца происходят вместе с ней.

очередь генерирует новое полоидальное во посредством закручивания силовых линий под действием силы Кориолиса в конвективных потоках. Благодаря такой связи становится возможным поддержание неадухационной магн. поля. Взаимодействие полоидального и торoidalного компонентов крупномасштабного магн. поля может иметь характер почти периодических нелинейных колебаний, что и является основой для интерпретации цикла С. а. как динамо-процесса.

С. а. оказывает значит. воздействие на процессы, происходящие в мезоатмосфере и околословном пространстве, в атмосфере и биосфере Земли (см. *Солнечные связи*).

Лит.: Витанский Ю. И., Солнечная активность, 2 изд., М., 1983; Вайнштейн С. И., Зельдович Е. В., Рузайкин А. К., Турбулентное динамо в астрофизике, М., 1980; Мофатт Г. К., Возбуждение магнитного поля в проводящей среде, пер. с англ., М., 1980; Паркер Е. Н., Космические магнитные поля, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1982; Прест Э. Р., Солнечная магнитогидродинамика, пер. с англ., М., 1985.

В. В. Соколов.

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ (батарея солнечных элементов) — устройство, непосредственно преобразующее энергию солнечного излучения в электрическую. Действие солнечного элемента (СЭ) основано на использовании явления внутр. фотоэффекта. Наиб. применение получили конструкции СЭ с $p-n$ -переходами и гетеропереходами, представляющие собой плоскую (базовую) полупроводниковую пластину с тонким фронтальным слоем полупроводника, имеющего тип проводимости, противоположный типу проводимости базовой области. При облучении в полупроводнике генерируются дополнительные носители заряда, к-рые перемещаются под действием электрич. поля $p-n$ -перехода и создают на внеш. выводах фототок.

Основные параметры солнечных элементов. При отсутствии внеш. нагрузки напряжение на выводах СЭ максимально и наз. в напряжении холостого хода U_{xx} . В замкнутом коротко фотоэлементе потечёт макс. фототок $I_{на}$ — ток короткого замыкания. При наличии внеш. нагрузки величины напряжения U_n на нагрузке и тока I_n имеют значения U_{xx} и $I_{на}$ соответственно. Величина $FF = I_n U_n / I_{на} U_{xx}$ наз. ф. а. к-ром заполнении и нагрузочной характеристике.

Важнейшим параметром СЭ является его к.д. (или эффективность) преобразования энергии и солнечного излучения в электрическую $\eta = I_n U_n / P_c$, где P_c — мощность солнечного излучения, падающего на поверхность СЭ. Эффективность СЭ определяется тем, что часть солнечного излучения с энергией фотона, меньшей ширины запрещённой зоны E_g полупроводника, проходит через СЭ без поглощения и в фотоэлектрич. отношении является бесполезной. Чем меньше ширина запрещённой зоны, тем большая доля солнечного света поглощается в нём.

Др. важная причина снижения к.д. СЭ — неполное использование энергии поглощённых фотонов. При генерации электронно-дырочных пар фотонами с энергией, превышающей ширину запрещённой зоны полупроводника, избыточная энергия излучения теряется при переходах внутри зоны за счёт соударений носителей с атомами решётки и переходит в тепло. Эти потери уменьшаются с увеличением E_g .

Ост. причинами дополнит. потерь, уменьшающих практически достижимые значения к.д., являются отражение части светового потока от поверхности СЭ (коэф. отражения для полупроводников, применяемых в СЭ, составляет ок. 30% и 3—5% при использовании просветляющих покрытий) и рекомбинац. потери, вызываемые тем, что часть возбуждённых фотоносителей не доходит до $p-n$ -перехода, рекомбинирует, а их энергия поредается решётке полупроводника (см. *Рекомбинация носителей заряда*). В фотоэлементах с $p-n$ -переходами существенны потери за счёт поверхностной рекомбинации, особенно для носителей, генерируемых

вблизи облучаемой поверхности КВ-частью солнечного света. Омические потери в СЭ приводят к уменьшению фактора заполнения нагрузочной характеристики.

Энергетич. характеристики С. б. определяются материалом фотоэлемента, конструктивными особенностями СЭ, кол-вом СЭ в батарее. Распространёнными материалами для СЭ являются Si, GaAs, CdS, CdTe (см. *Полупроводниковые материалы*). Наиб. высокий к.д. получен в СЭ на основе Si (17% при освещении в земных условиях) и в СЭ на основе GaAs (22%). Конструктивно С. б. обычно выполняются в виде плоской панели и СЭ, защищённых прозрачными покрытиями. Число СЭ в батарее может достигать неск. сотен тысяч, площадь панели — тысяч м², ток С. б. — сотен А, напряжение — сотен В, генерируемая мощность — неск. десятков и сотен кВт.

Увеличение к.д. может быть получено в каскадных СЭ с неск. $p-n$ -переходами в полупроводниках с разл. шириной запрещённой зоны. Солнечный спектр может быть распущён либо селективными зеркалами, либо посредством расположения неск. СЭ один за другим с убыванием ширины запрещённой зоны СЭ по ходу солнечных лучей. Расчётные значения к.д. для двухкаскадных СЭ достигают 45%. Ост. перспективы в реализации монокристаллических каскадных СЭ заключаются в трудности осуществления последоват. соединения верхнего и нижнего элементов без внесения дополнит. омических и оптич. потерь.

Достоинства С. б. — их простота, надёжность и долговечность, малая масса и миниатюрность СЭ, генерирование энергии без загрязнения окружающей среды; осн. недостаток — высокая стоимость. Применяются на космич. летат. аппаратах, где они занимают доминирующее положение среди др. источников автономного энергоснабжения. В земных условиях С. б. используются для питания устройств автоматики, переносных радиостанций, радар. приборов, для каждой антикоррозийной защиты нефте- и газопроводов и др.

Лит.: Васильев А. М., Ландсман А. П., Полупроводниковые фотопреобразователи, М., 1971; Алферов Ж. И., Андреев В. М., Перспективы фотоэлектрического метода преобразования солнечной энергии, Черногория, 1981; Кавая М. В., Гетерогенные, каскадные и комбинированные фотопреобразователи на основе арсенида галлия, в кн. Фотоприёмники и фотопреобразователи, Л., 1988; Колтуш М. М., Солнечные элементы, М., 1987.

СОЛНЕЧНАЯ КОРОНА — внешняя, наиболее горячая и разреженная часть атмосферы Солнца, простирающаяся до Земли и далее. Она отделена от хромосферы тонким переходным слоем, в к-ром темп-ра резко возрастает от хромосферной ($\approx 10^4$ К) до коронной ($\approx 10^6$ К) значений. Темп-ра С. к. достигает максимума ($\approx 10^6$ К) на высоте ок. $1/10$ радиуса Солнца от его поверхности и очень медленно падает (до $\sim 10^5$ К вблизи орбиты Земли) во внеш. короне (части С. к. выше температурной максимума), непрерывно расширяющейся в межпланетное пространство в виде *солнечного ветра*. Корональная плазма полностью ионизована, её хим. состав практически такой же, как в солнечной фотосфере. Средний кинетич. темп-ра С. к. превышает 10^6 К. В полярных областях короны темп-ра ниже средней (возможно, в результате чрезвычайно сильного солнечного ветра, исходящего из полярных корональных вёрв). В активных областях (см. *Солнечная активность*) темп-ра повышена примерно на $0,3 \cdot 10^6$ К, в корональной части *спящих* на Солнце — может достигать десятков млн. К.

Ср. концентрация электронов в ниж. части спокойной внутренней С. к. $\sim 10^{18}$ см⁻³. Поскольку плазма С. к. электрически нейтральна, концентрация ионов (в осн. протонов) в ней такая же. С ростом расстояния от солнечной поверхности концентрация частиц падает. На расстоянии одного радиуса Солнца она $\sim 10^8$ см⁻³, на расстоянии четырёх радиусов $\sim 10^5$ см⁻³, десяти радиусов $\sim 10^4$ см⁻³.

Вследствие низкой плотности корональной плазмы её излучат. способность (см. *Излучение плазмы*) мала, что

приводит к высокой темп-ре даже при слабом нагреве. Нагрет. С. к. проскакивает за счёт энергии, приходящей из более низких слоев атмосферы Солнца. Полагают, что он связан с магн. потоком, выходящим из границ супергранул, ячеек. Нагрев может быть вызван как альвеновскими и магнитословковыми волнами (см. *Волны в плазме*), так и прямой диссипацией энергии магн. поля. Механизм превращения магн. энергии в тепловую и кинетическую, скорее всего, аналогичен механизму, предложенному для объяснения солнечных вспышек и обусловлен *пересоединением* магн. силовых линий. По-видимому, посылку в корону проскакивает мегоцикл, малые микровспышки, осуществляющие её нагрев. Высокая теплопроводность корональной плазмы обеспечивает отток энергии из области температурного максимума в основном вниз, в хромосферу, но частично и вверх. Существенно меньшая часть энергии уходится из С. к. её собой, излучением.

С. к. наблюдается в широком диапазоне спектра — от рентгеновского до радиоизлучения. В видимом диапазоне 99% полного излучения С. к. представляет собой рассеянное на свободных электронах (и вследствие этого линейно поляризованное, т. е. томсоновское *рассеяние света*) непрерывное излучение фотосферы (*K*-корона) (из-за высокой темп-ры фраунгоферовы линии в *K*-короне полностью замывают). Во внутр. короне на него налагается линейчатое излучение (собственное корональное излучение), содержащее запрещенные спектральные линии высокоионизов. атомов железа, ванадия, кальция и др. (*E*-корона). Наблюдаемое во внеш. короне осв. свечение физически не связано с короной и создается в результате рассеяния и дифракции фотосферного излучения на межпланетных пылевых частицах (*F*-корона). *K*- и *F*-компоненты образуют «облаку» С. к. Яркость её в лимбе составляет ок. 10^{-9} яркости центра солнечного диска и довольно быстро падает с удалением от лимба. Она наблюдается во время полных солнечных затмений, а также с помощью коронографов с внеш. затенением, устанавливаемых на аэростатах, спутниках либо высоко в горах. Общая форма С. к. меняется с фазой *солнечного цикла*: почти сферична в годы максимума и сильно вытянута вдоль экватора в годы минимума.

Излучение С. к. возникает в условиях, сильно отличающихся от термодинамич. равновесия. Вследствие высокой темп-ры в высокой степени ионизации вещества короны большая часть её излучения приходится на рентг. область и далёкую УФ-область спектра. Спектр короны в этом диапазоне в осн. состоит из многочисл. эмиссионных линий. Мн. из них относятся к разрешённым переходам высокоионизов. атомов. Спектральные линии в ближнем УФ-диапазоне в основном запрещённые. Всё солнечное излучение с $\lambda < 200$ Å и радиоизлучение в метровом диапазоне исходит из С. к.

С. к. обладает сложной структурой, определяемой в осн. магн. полем Солнца. Вследствие чрезвычайной разреженности коронального газа даже слабые магн. поля, проникающие из фотосферы, оказывают существ. влияние на динамику и строение короны. Напряжённость магн. поля в короне не превышает, по-видимому, $1-10$ Гс.

Области с «открытыми» конфигурациями магн. поля — корональные дыры — обширные области в С. к. с пониженной плотностью и темп-рой, практически не дающие рентг. излучения. Они занимают ок. 20% поверхности Солнца, существуют в течение неск. оборотов Солнца. Полярные корональные дыры существуют почти постоянно.

Области с замкнутыми магн. силовыми линиями — дельтовые структуры — типичны для внутр. короны. Многочисл. яркие петли и системы петель, по-видимому, очерчивают силовые линии магн. поля и часто расположены над активными областями или связывают разл. активные области.

Над активными областями возникают корональные конденсации — образования, анатомически более плотные ($\text{до } 10^{19}$ электронов в 1 см^3) и более горячие (темп-ра превышает $3 \cdot 10^6$ К), чем окружающее вещество, состоящее из систем ярких петель.

В рентг. диапазоне видны яркие точки, распределённые по всему диску Солнца. Они очень компактны, характерное время жизни ≈ 8 ч, магн. поле ≈ 10 Гс. За сутки возникает ок. 1500 точек. Яркие точки служат корональным проявлением малых активных областей вспыхивающего магн. потока и, по-видимому, состоят из осн. петель. Магн. поток, выходящий всеми рентг. точками, составляет значит. долю общего магн. потока, выходящего из солнечной поверхности. Кол-во ярких точек меняется в противофазе с числом солнечных пятен.

Характерной особенностью С. к. является её лучистое строение. *Корональные лучи* (стримеры) — это почти радиальные крупномасштабные замкнутые структуры (плазмы, опалеха, лучи), «увенчанные» расходящимися силовыми линиями; имеют повш. плотность по сравнению с окружающей короной и могут простираться до 10 и более радиусов Солнца от его поверхности. Вблизи полюсов в минимуме солнечной активности появляются лучевидные структуры — полярные шпательки.

В С. к. часто происходят вестационные сравнительно кратковременные явления — корональные транзиенты — быстрые изменения структуры и яркости короны, охватывающие её значит. часть и приводящие к выбросу в межпланетное пространство большого кол-ва плазмы ($\approx 10^{18}$ г) со скоростями до 1200 км/с. Полная кинетич. энергия транзientа иногда превышает 10^{28} эрг, т. е. энергию большой солнечной вспышки. Источником энергии транзientов, по-видимому, является энергия магн. поля. Транзientы часто имеют вид обширной аркады ярких петель. Большинство транзientов связано с eruptивными *протуберанцами* и большими вспышками.

Лит.: П. р. с. Э. Р. Солнечная магнитогидродинамика, пер. с англ., М., 1985; S. O. u. P. V., Magnetically driven coronal transients, «Adv. Space Res.», 1991, v. 11, № 1, p. 179.

Т. П. Хромос.

СОЛНЕЧНАЯ ПОСТОЯННАЯ — полное количество лучистой энергии Солнца, падающее вне атмосферы Земли на площадку единичной площади, расположенную перпендикулярно солнечным лучам на ср. расстоянии от Земли до Солнца (1 а. е.). В СИ С. п. равна $(1369 \pm 14) \text{ Вт/м}^2$. В нач. 1980-х гг. была обнаружена переменность С. п. с амплитудой 0,1–0,2%, связанная с солнечным циклом. Позже обнаружены вариации С. п. с меньшими характерными временами (вплоть до часов). Уменьшение С. п. связано с появлением на Солнце очень больших групп пятен, слабое увеличение — с солнечными факелами. Появление на диске Солнца пятен и факелов объясняет лишь 50–70% всех наблюдаемых вариаций С. п. Возможными причинами циклич. переменности С. п. могут быть также изменения магн. поля и его активных областей, эффективности конвекции диаметра Солнца и т. п. Знание солнечной постоянной необходимо для решения ряда проблем астрофизики, геофизики, экологии и др. разделов естествознания.

Лит.: Макарова Е. А., Харитонов А. В., Кавачевская Т. В., Поток солнечного излучения, М., 1991.

М. А. Давыдов.

СОЛНЕЧНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ (гелиосейсмология) — область астрофизики, в к-рой изучаются структура, состав и динамика солнечных недр с помощью анализа осцилляций, наблюдаемых на поверхности Солнца. Многие волновые движения, обнаруженные при измерении поверхности яркости Солнца или доплеровских сдвигов фотосферных спектральных линий, обусловлены колебаниями внутр. областей. Форма и период этих колебаний зависит от темп-ры, плотности, хим. состава и движений вещества внутри Солнца. Поэтому они служат чувствительными индикаторами внутр. строения. Амплитуда колебаний крайне мала; соответствующе-

щие изменения радиуса и яркости Солнца не превышают 0,001%. Тем не менее удалось зарегистрировать широкий спектр колебаний и на его основе получить данные о внутр. строении Солнца.

Основные свойства колебаний Солнца. Колебат. движения Солнца, как и всякой сплошной среды, возникают, если нек-рый элемент газа при смещении из положения равновесия испытывает действие силы, стремящейся вернуть его в исходное положение. На Солнце возвращающие силы могут быть трёх типов: 1) градиенты газового давления, возникающие при сжатиях и разрежениях среды. Они вызывают акустич. колебания; 2) выталкивающие (архимедовы) силы, обусловленные неоднородным распределением вещества в поле тяжести. В конвективно устойчивых слоях эти силы создают внутр. гравитат. колебания; 3) инерционные (корриолисовы) силы, связанные с вращением Солнца. Они приводят к инерционным колебаниям, аналогичным волнам Россби в земной атмосфере.

Колебания могут распространяться в виде волн в определенных областях (сферич. слоях) внутри Солнца. Если эти слои снизу и сверху ограничены зонами, где волновое распространение невозможно, то волны отражаются от границ областей распространения и будут там захвачены. В результате многократного отражения от границ и интерференции захваченных волн образуются стоячие волны, к-рые часто называют собств. колебаниями или модами. Каждая мода имеет свою частоту (зависит от условий в области захвата) и определенную пространственную картину смещений: сферич. поверхность разбивается на отдельные колеблющиеся участки, разделенные вдоль меридианов и параллелей узловыми линиями, на к-рых газ неподвижен; вдоль радиуса внутри области захвата колебания имеют пучности и узлы, а вне её — экспоненциально затухают. Зная частоту и общую картину колебаний на поверхности, можно восстановить радиальную структуру моды и определить условия в области захвата.

Ещё не вполне ясно, каким образом на Солнце происходит возбуждение колебаний. Возможно, они являются результатом турбулентных движений в конвективной зоне, способных случайным образом возбуждать и гасить колебания. В энергию колебаний может преобразовываться избыток тепла, возникший при увеличении скорости ядерных реакций или при нек-рой задержке потока лучистой энергии в результате локального сжатия вещества.

Акустич. волны (см. *Упругие волны*) имеют периоды от 3 мин до 1 ч. Они распространяются со скоростью звука и отражаются за счёт градиентов плотности и темп-ры во внутр. областях Солнца. Верх. граница отражения лежит сразу под видимой поверхностью (*фотосферой*) Солнца, где плотность резко падает с высотой. Здесь отражаются все волны, для к-рых циклич. частота ω меньше т. н. акустич. частоты образования: $\omega_a = a/2L$, где a — скорость звука, L — характерный масштаб изменения плотности. В фотосфере $a \approx 6 \cdot 10^8$ см/с, $L \approx 10^7$ см; поэтому $\omega_a \approx 3 \cdot 10^{-2}$ с⁻¹. Соответственно, мин. период захваченных волн $P_a = 2L/\omega_a \approx 200$ с. Поскольку акустич. волны с большими периодами отражаются от более глубоких слоев, то на поверхности легко всего наблюдаются волны с периодами, близкими к P_{a1} — т. н. пятиминутные колебания. Акустич. волна, отражённая от этой верх. границы, распространяется вниз. В результате роста темп-ры с глубиной (а значит, и скорости звука) более глубокая часть волнового фронта движется с более высокой скоростью. Поэтому фронт волны постепенно изгибается, пока волна не поворачивает обратно к поверхности. На нижней отражающей границе горизонтальный компонент фазовой скорости волны равен скорости звука. Т. о., захваченные акустич. волны распространяются вдоль дугообразных траекторий под поверхностью Солнца. Стоячие акустич. волны наз. *p*-модами; они наиб. подробно изучены в наблюдениях.

Внутр. гравитат. волны (см. *Внутренние волны*) имеют периоды, превышающие 20 мин. Они могут распространяться только в области с конвективно устойчивой стратификацией (расслоением) вещества и, кроме того, при условии, что их частота меньше частоты плавутичи N (частоты Брента — Вэйлля):

$$N^2 = g\beta \left[\frac{dT}{dr} - \left(\frac{dT}{dr} \right)_{\text{ад}} \right],$$

где g — локальное ускорение силы тяжести, $\beta = -\rho^{-1}(\partial\rho/\partial T)_P$ — коэф. теплового расширения, ρ — плотность, (dT/dr) — радиальный градиент темп-ры на Солнце, $(dT/dr)_{\text{ад}} = -\beta g/c_P$ — т. н. адиабатич. градиент, c_P — уд. теплоёмкость. В области лучистого теплопереноса, устойчивой относительно конвекции, $N^2 > 0$. В конвективной зоне $N^2 < 0$. Поэтому внутр. гравитат. волны захвачены глубоко в недрах Солнца под конвективной зоной. Верхняя и нижняя границы отражения находятся там, где N приближается к 0. Стоячие внутр. гравитат. волны наз. *g*-модами. Надёжных наблюдат. данных о свойствах этих мод пока не получено.

Инерционные волны представляют собой почти горизонтальные вихревые движения газа с большими периодами, сравнимыми с периодом вращения Солнца (≈ 25 сут). На распространение этих волн вдоль радиуса Солнца влияет сила плавутичи. В зависимости от частоты они могут распространяться либо в центр. зоне лучистого переноса энергии, где $N^2 > 0$, либо в конвективной зоне ($N^2 < 0$). В последнем случае область захвата является узкой слой в верх. части конвективной зоны, характеризующийся глубоким минимумом N^2 (область неэффективной конвекции). Захваченные здесь волны могут наблюдаться на поверхности Солнца. Стоячие инерционные волны наз. *r*-модами; пока их наблюдать не удалось.

Теоретическое описание акустических и гравитационных мод. Поскольку периоды *p*- и *g*-мод намного меньше периода вращения Солнца, то в первом приближении преобладают влияние вращения и колебания рассматриваются как малые периодич. возмущения равновесного состояния Солнца. В сферич. системе координат (r, θ, ϕ) распределение амплитуд стоячих волн по поверхности постоянного радиуса описывается сферич. гармониками $Y_l^m(\theta, \phi)$ (см. *Сферические функции*), где l — степень сферич. гармоники — целое число, равное полному кол-ву узловых линий на поверхности и задающее горизонтальную компоненту волнового вектора $k_A = \sqrt{l(l+1)/r}$; m — азимутальный порядок — целое число, принимающее значения от $-l$ до $+l$ и определяющее число узловых линий, пересекающих экватор. Глубинная структура мод характеризуется радиальным порядком n — числом узлов вдоль радиуса. Собств. частоты и распределение амплитуд колебаний вдоль радиуса находится в результате решения задачи на собств. значения, для систем обыкновенных дифференц. ур-ний, вытекающих из ур-ний гидродинамики в линейном приближении. В КВ-приближении решения этих ур-ний пропорциональны $\exp(ik_r r)$, где радиальный компонент волнового вектора k_r связан с частотой ω дисперсионным соотношением

$$k_r^2 = (\omega^2 - N^2) \left(\omega^2 - L_l^2 \right) (\omega a)^{-2},$$

$$L_l^2 = l(l+1)a^2 r^{-2}. \quad (1)$$

Глобальные свойства осцилляций Солнца удобно рассмотреть с помощью т. н. диаграммы распространения, на *k*-*r*ой изображены траектории критич. частот N^2 и L_l^2 по радиусу от центра до внем. атмосферы Солнца (рис. 1). Собств. колебания возможны, если зона распространения волн ($k_r^2 > 0$) ограничена с обеих сто-



Рис. 1. Диаграмма распространения колебаний для стандартной модели Солнца. Горизонтальные прямые показывают область захвата колебаний трёх типов: акустических (p -моды), внутренних гравитационных (g -моды) и иеронических (r -моды). Значения квадратов критических частот N^2 и L_i^2 даны в единицах $GM_{\odot}/R_{\odot}^3 = 3,9 \cdot 10^{-7} \text{ с}^{-2}$, A — высота над уровнем фотосферы.

ров зонами с $k_r^2 < 0$ и выполнено определ. условие для фазы колебаний:

$$\int_{r_a}^{r_b} k_r dr = \pi(n + \alpha), \quad (2)$$

где r_a и r_b — точки отражения волн ($k_r^2 = 0$), α — число порядка l , зависящее от характера отражающих границ. Из (1) и (2) следует, что для каждой степени $l = 0, 1, 2, \dots$ существуют две последовательности собств. колебаний: акустические (p) моды с частотами $\omega_{p_1} < \omega_{p_2} < \omega_{p_3} < \dots$, увеличивающимися при возрастании радиального порядка n , и гравитационные (g), моды, частоты k -рых уменьшаются с ростом n : $\omega_{g_1} > \omega_{g_2} > \omega_{g_3} > \dots$ ($\omega_{g_n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$). Если вращением пренебрегать, то ввиду азимутальной симметрии частота не зависит от значения m , т. е. частота моды с данными n и l ($2l + 1$)-кратно вырождена по m .

Результаты наблюдений и анализа колебаний Солнца. Колебат. движения газа на поверхности Солнца, называемые «пятиминутными колебаниями», открыты Р. Лейтоном (R. Leighton) в 1960. Дальнейшие детальные наблюдения показали, что «пятиминутные колебания» представляют собой наложение большого числа ($\sim 10^7$) стоячих акустич. волн с характерными длинами на поверхности от $\sim 0,005 R_{\odot}$ до $2R_{\odot}$ (им соответствуют степени сферич. гармоник $0 \leq l \leq 1000$). В С. с. принято разделять акустические колебания на три

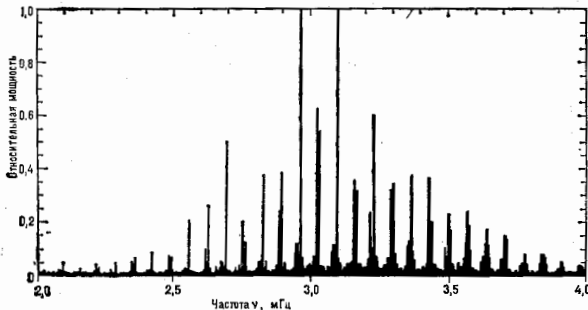


Рис. 3. Спектр акустических мод низкой степени, полученный в результате измерений доплеровских смещений спектральных линий в излучении от всего диска Солнца (А. Клавьер и др., 1984).

класса в зависимости от степени гармоник: моды высокой степени ($100 < l < 1000$), моды промежуточной степени ($4 < l \leq 100$) и моды низкой степени ($0 \leq l \leq 4$).

Результаты наблюдений мод высокой степени представлены на рис. 2 в виде зависимости частоты колебаний $\nu = \omega/2\pi$ от степени l или волнового числа k_l

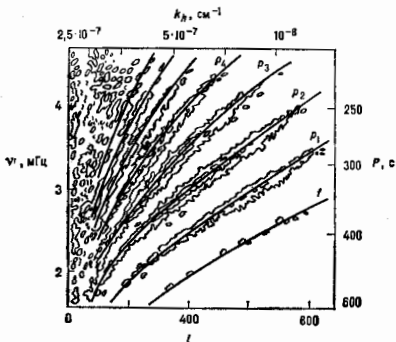


Рис. 2. Спектр мощности акустических мод высокой степени, наблюдавшихся Ф. Л. Дэйбнером, в зависимости от частоты ν (или периода P) и горизонтального волнового числа k_l (или степени l). Плотность мощности колебаний в расчёте на единичные интервалы частот и волновых чисел представлена изоинтиями. Жирные кривые — результат теоретического расчёта для стандартной модели Солнца.

[Ф. Л. Дэйбнер (F.-L. Deubner), 1974]. Отд. ветви на этой диаграмме соответствуют модам с радиальными порядками $n = 1 - 7$. Самая нижняя ветвь, обозначенная как l -мода, соответствует поверхностным гравитационным, k -рые по своей природе аналогичны волнам на поверхности жидкости. Акустич. моды высокой степени захвачены в конвективной зоне (радиус нижней отражающей границы от $0,9 R_{\odot}$ до $1 R_{\odot}$), и поэтому от её структуры зависит частота мод. Установлено, что наилучшее согласие наблюдаемых частот с теоретическими достигается, если глубина конвективной зоны несколько больше, чем в стандартной модели (см. в ст. Солнце раздел Внутреннее строение Солнца); $0,3 R_{\odot}$ вместо $0,27 R_{\odot}$.

Наблюдения мод промежуточной степени и соотношения (1) и (2) позволили найти зависимость $a^2(r)$. Она хорошо согласуется со стандартной моделью внутри строения Солнца при $0,3 R_{\odot} < r < 1 R_{\odot}$, но есть указание на то, что в районе от $0,3 R_{\odot}$ до $0,5 R_{\odot}$ скорость звука выше, чем в стандартной модели, примерно на 1%. По этим данным не удаётся найти распределение скорости звука в солнечном ядре при $r < 0,2 R_{\odot}$ потому, что акустич. волны с $l \geq 4$ туда не проникают.

Информация о структуре ядра содержится в спектре p -мод низкой степени, для k -рых $0 \leq r_0 \leq 0,2 R_{\odot}$. Эти моды были открыты при измерениях долготерпых сдвигов спектров длинных линий в излучении от всего диска Солнца [А. Клавери (A. Claverie) и др., 1979]. Спектр колебаний состоит из большого числа пар дискретных пиков, равностоящих друг от друга на 68 мкГц (рис. 3). Из теории известно, что эти колебания имеют большое число узлов вдоль радиуса ($n = 12 - 35$) и для их частот справедливо соотношение:

$$\nu_{n,l} = \left(n + \frac{l}{2} + \beta_{n,l} \right) \nu_0,$$

где $\nu_0 = \left(2 \int_0^{R_{\odot}} dr a(r)^{-1} \right)^{-1}$, $\beta_{n,l}$ — число порядка l . Следова-

тельно, пары частот в наблюдаемом спектре образованы модами с наборами параметров (n, l) и $(n-1, l+2)$ и разделены интервалами $\nu_0/2 \approx 68$ мкГц. Величина ν_0 слабо зависит от внутр. строения, но значение разности частот между соседними p -модами $\nu_{n,l} - \nu_{n-1, l+2} = \Delta_{n,l}$ (≈ 10 мкГц) может служить индикатором структуры центральных областей Солнца. Измеренные значения $\Delta_{n,l}$ расходятся с рассчитанными для стандартной модели не более чем на 70% (табл.), но даже это отличие примерно в 10 раз больше ошибок измерений и неопределённости в расчётах. Значит, некоторые из предположений стандартной модели Солнца неточны. Возможно, вследствие неоднородностей в газовом облаке, из которого образовалось Солнце, первоначальный хим. состав ядра отличался от состава оболочки. Одна из моделей предполагает, что первоначальное содержание тяжёлых элементов было примерно в 10 раз меньше, чем наблюдается ныне на его поверхности, и что в ходе эволюции происходило обогащение оболочки тяжёлыми элементами из окружающей среды. Другое возможное отличие от стандартной схемы эволюции Солнца состоит в том, что вещество в зоне лучистого переноса энергии по каким-то причинам частично перемешивалось, и поэтому кол-во водорода в ядре выше, чем в стандартной модели. Обе эти модели предсказывают поток нейтрино от Солнца, k -рый согласуется с наблюдаемым; однако частоты p -мод отличаются от измеренных сильнее, чем в случае стандартной модели.

Важная информация о параметрах солнечного ядра может быть получена из наблюдаемых гравитац. мод, периоды k -рых лежат в диапазоне 100—300 мин. Эти моды должны иметь небольшие значения степени ($l = 1 \div 4$) и высокие радиальные порядки ($n \approx 10 \div 20$). Теоретич. значения периодов колебаний таковы:

$$P_{n,l} = P_0 \left(n + \frac{l}{2} + \gamma_{n,l} \right) [l(l+1)]^{-1/2},$$

где $P_0 = 2\pi^2 \left(\int_0^{r_c} N dr / r^3 \right)^{-1}$, r_c — радиус границы конвективной зоны, $\gamma_{n,l}$ — числа порядка l . Для фиксированного l периоды колебаний почти равностоят друг от друга на величину $P_0 \sqrt{l(l+1)}$. Измеренные и теоретич. значения P_0 даны в табл. Пока данные наблюдений g -мод недостаточно надёжны для уверенных выводов о строении Солнца.

В спектре долгопериодных осцилляций Солнца наблюдается также стабильное изолор. колебание с периодом 160,01 мин, k -рое не удаётся объяснить в рамках стандартной модели внутр. строения (А. Б. Северный и др., 1976).

С. с. позволяют также определять скорости вращения внутр. слоёв Солнца. Вращение Солнца снимает вырождение частот p - и g -мод по параметру m : для заданного значения l собств. частота расщепляется на $(2l+1)$ частот, соответствующих $m = -l, -(l-1), \dots, (l-$

$-1)$, l . Расщепление частот связано с тем, что из-за эффекта Доплера волны, распространяющиеся в направлении вращения, сдвинуты к более высоким частотам, в то время как волны, распространяющиеся против вращения, сдвинуты к более низким частотам. Величина расщепления для акустич. мод определяется в осн. зависимостью угл. скорости вращения в экваториальной плоскости Ω_0 от радиуса:

$$\nu_{n,l,m} - \nu_{n,l,0} = m \langle \Omega_0 \rangle (2\pi)^{-1},$$

где $\langle \Omega_0 \rangle = \int_{r_0}^{R_{\odot}} \Omega_0(r) a^{-1} dr / \int_{r_0}^{R_{\odot}} a^{-1} dr$ — ср. угл. скорость в области захвата волн. Поскольку радиусы внутр. грани-

цы отражения r_0 отличаются для мод с разными l и l , то по известному расщеплению частот можно найти ср. значения угл. скорости в разных областях по радиусу. Измерения и анализ вращательного расщепления частот p -мод показывают, что ядро, по-видимому, вращается в 2 раза быстрее, чем остальная часть Солнца [Т. Доваль (T. Duvall) и Дж. Харви (J. Harvey), 1984].

Для более прецизионных измерений частот акустич. мод разработаны методы, позволяющие определять зависимость угл. скорости вращения от широты и напряжённости магн. поля внутри Солнца.

Лит.: Nonradial oscillations of stars, Tokyo, 1979; Кокус Дж., Теория звездных пульсаций, пер. с англ., М., 1983; Ли в Я. А. Хер Дж. и др., Гелиосейсмология, «В мире науки», 1985, № 11, с. 4; Северный А. Б., Котов В. А., Шаптал Т. Т., Колебания Солнца с периодом 160 мин и другие долготерпые колебания: анализ спектра мощности за 9 лет наблюдений и интерпретация, Изд. Крым. астрофиз. обс., 1985, т. 71, с. 3; Christensen-Dalsgaard J., Gough D., Thompson J., Seismology of the Sun, «Science», 1985, v. 229, № 4717, p. 923.

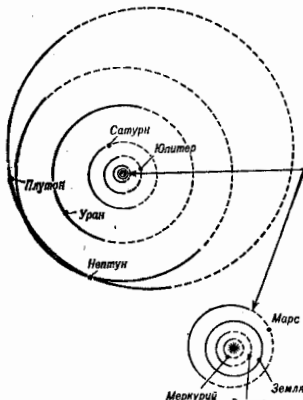
А. Г. Лоскутеев.

Табл. 5.—Спектральные характеристики p - и g -мод $\Delta_{n,l}$ и P_0 — значения параметра $\Delta_{n,l}$ для $l=0$ и l , усреднённые по всем модам в интервале частот 2,0—4,0 мГц

	$\Delta_{n,l}$, мкГц	$\bar{\Delta}_{n,l}$, мкГц	P_0 , мин
Наблюдения	$9,2 \pm 0,6$	$9,7 \pm 0,03$	38 ± 3
Стандартная модель	10,0	10,2	35,4
Модель с перемешиванием вещества в ядре Солнца	16,8	17,0	56,9
Модель с пониженным содержанием тяжёлых элементов в лучистой зоне	13,2	10,3	39,6

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА — состоит из Солнца, планет и спутников, множества астероидов и их осколков, комет и межпланетной среды. С. с. расположена вблизи центральной плоскости Галактики на расстоянии ок. 8 кпк от её центра. Линейная скорость вращения С. с. вокруг галактич. центра ок. 220 км/с, скорость движения С. с. относительно межзвёздного газа 22—25 км/с. Вещ. границы С. с. можно считать сферой гравитац. влияния Солнца (сфера Хилла) радиусом ≈ 1 пк $\approx 2 \cdot 10^4$ а. е. (размеры большинства подсистем С. с. существенно меньше).

Солнце — медленно вращающаяся звезда с массой $M_{\odot} \approx 1,989 \cdot 10^{33}$ г, радиусом $R_{\odot} \approx 6,96 \cdot 10^{10}$ см, моментом кол-ва движения $\approx 1,6 \cdot 10^{46}$ г·см²/с. Девять планет являются главными спутниками Солнца, их суммарная масса $\approx 1,743 M_{\odot}$, полный момент кол-ва движения $\approx 3 \cdot 10^{46}$ г·см²/с. Суммарная масса всех остальных наблюдаемых компонент С. с., включая облако комет, $\lesssim 10^{-4} M_{\odot}$. Ок. 98% суммарной массы планет приходится на долю планет-гигантов. Схема расположения планетных орбит в С. с. изображена на рис. Орбиты представляют собой эллипсы, в одном из фокусов k -рых расположено Солнце. Орбита Плутона обычно считается границей планетной системы (≈ 39 а. е.). Простран-



ство между планетами заполнено межпланетной средой, осн. компонентом к-рой является *солнечный ветер*, простирающийся до расстояний ~ 100 а. е., где его динамич. давление уравновешивается давлением межзвёздной среды. Предполагается, что на периферии С. с. (10^4 — 10^5 а. е. от Солнца) находится т.н. кометное облако Оорта. Ср. хим. состав С. с. определяется массивным Солнцем: 74,6% H, 20,7% He; на долю остальных элементов приходится менее 5% (по массе). Возраст Солнца и С. с. по изотопным данным оценивается в 4,6 млрд. лет (см. *Космохронология, Происхождение Солнечной системы*).

СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ — система прямых или опосредованных физ. связей между процессами на Солнце и Земле.

Влияние Солнца на Землю многогранно и неоднозначно (обратное влияние Земли на Солнце ничтожно мало). Прежде всего Земля непрерывно получает от Солнца почти неизменный поток энергии (см. *Солнечная постоянная*), обеспечивающий наблюдаемый уровень освещённости и ср. темп-ру её поверхности (см. *Тепловой баланс Земли*). Кроме того, Земля подвергается комбиниров. воздействию излучений от нестационарных солнечных процессов (солнечных возмущений) — проявлений *солнечной активности*. Хотя не все звенья цепочки С.-з. с. (рис. 1) одинаково изучены,

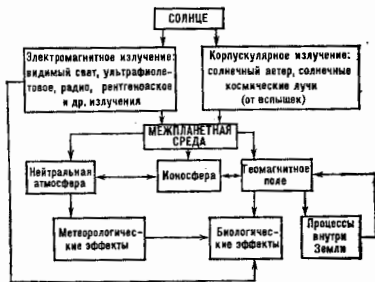


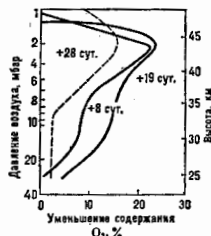
Рис. 1. Схема солнечно-земных связей.

в общих чертах качественная картина С.-з. с. представляется ясной.

В переносе энергии солнечных возмущений участвует вся среда между Солнцем и Землей. Большую роль играет межпланетное магн. поле, к-рое регулирует потоки *космических лучей* галактич. и солнечного (вспышечного) происхождения, а также определяет особенности взаимодействия *солнечного ветра* с *магнитосферой Земли*. Солнечные возмущения воздействуют гл. обр. на самые внеш. оболочки Земли — магнитосферу и ионосферу (см. *Атмосфера вергиля*). Это воздействие не сводится только к изменению потоков энергии, поступающих к Земле в том или ином диапазоне. Оно является также спусковым механизмом, вызывающим перераспределение накопленной в оболочках Земли энергии. Перераспределение может происходить плавно либо скачкообразно (триггерный механизм).

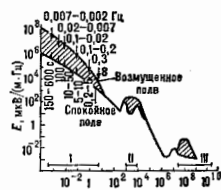
Влияние Солнца на Землю наиболее отчетливо проявляется после *вспышки на Солнце*. Эл.-магн. излучение вспышки в УФ- и рентг. диапазонах вызывает доп. ионизацию верхних слоев ионосферы, что приводит к кратковрем. ухудшению (или даже полному прекращению) радиосвязи на освещённой стороне Земли (десяти минут). Ускоренные во вспышке частицы, вторгаясь в ниж. ионосферу и стратосферу полярных широт, вызывают длит. ухудшение КВ-радиосвязи (десяти часов) и способствуют опустошению озонового слоя (в отд. случаях до 10—20%, рис. 2). Потоки солнечных космич. лучей от мощных вспышек представляют собой

Рис. 2. Уменьшение содержания озона в стратосфере Северного полушария Земли под влиянием солнечных космических лучей после вспышки 4 августа 1972. Сплошные кривые — данные наблюдений в интервале широт 75—80°N через 8 и 19 суток после вспышки; штриховая линия — расчётное содержание озона через 28 суток после вспышки (в % относительно предвспышечного уровня).



один из гл. источников радиац. опасности для экипажей и оборудования космич. аппаратов. Кроме того, вспышка генерирует мощную ударную волну и выбрасывает в межпланетное пространство облако плазмы. Спустя 1,5—2 сут они достигают Земли и вызывают магн. бурю (см. *Магнитные вариации*), усиление *полярных сияний*, возмущения ионосферы, понижение интенсивности галактич. космич. лучей и т. д. В результате флуктуаций мощности солнечного ветра в магнитосфере и ионосфере генерируется широкий спектр эл.-магн. волн с частотами 0,001—10,0 Гц, к-рые доходят до поверхности Земли. Во время магн. бурь интенсивность этого излучения возрастает в 10—100 раз (рис. 3). Магнитосферные и ионосферные вариации (см., напр., *Земной магнетизм*) влияют не только на средства магн.

Рис. 3. Спектр электромагнитного поля на поверхности Земли. По вертикальной оси — напряжённость электрического поля E, по горизонтальной — высота колебаний (Гц). Стрелками отмечены частоты, на которых наблюдаются короткопродолжительные космич. выбросы геомагнитного поля, вызванные изменением солнечной активности, и соответствующие им периоды. Цифры I—III отмечены опис. прозрачности для электромагнитных волн в атмосфере Земли.



навигации и радиосвязи, но и на кабельную связь (телекс и телефон), работу линий электропередач, нефти и газопроводов и т. п.

В климатологии и метеорологии получены доказательства статистич. связи между частотой засух и 22-летним солнечным циклом, изменением приземного давления и мощностью солнечного ветра, поведением др. метеопараметров и уровнем геомагн. возмущённости в целом (солнечно-тропосферные связи). Эти эффекты географически обусловлены (горы, граница суша — океан и т. п.) и связаны с распределением аномалий геомагн. поля, с областями неустойчивости атмосферы.

Статистически установлена циклич. связь (рис. 4) между уровнем солнечной и геомагн. активности и ходом ряда процессов в биосфере Земли — динамикой популяций животных, эпидемий, эпизоотий и т. п. (солнечно-биосферные связи). Показано также, что колебания геомагн. поля могут вызывать ответную реакцию

химически активных веществ, резко изменяющих электронную концентрацию в данной области ионосферы, и т. д. Гл. преимуществом лабораторных и натурных экспериментов — возможность контролировать нек-рые нач. условия и параметры.

Изучение С.-а. с. не только является фундам. науч. проблемой, но и имеет большое прикладное значение. В частности, доказана возможность создать искусственный радиац. пояс Земли, изменить свойства ионосферы и генерировать ал.-магн. НЧ-излучение над заданным районом. Диагностика и прогноз радиац. обстановки в космосе, магнитосферных и ионосферных возмущений крайне необходимы для решения практич. задач в области космонавтики и радиосвязи, транспорта, энергетики и нефтегазовой пром-сти, метеорологии и климатологии, сельского хозяйства, биологии и медицины. Выяснялся связь солнечно-земной физики с глобальными экологич. проблемами и долговрем. изменениями в окружающей среде.

Лит.: Витянский Ю. И., Солнечная активность, 2 изд., М., 1983; Чижиковский А. Л., Земное эхо солнечных бурь, М., 1976; М., 1976; А. Косов, С.-И., Ченгис, С., Солнечно-земная физика, вып. 5, вып. 6, М., 1974; Витянский Ю. И., Оль А. И., Сазонова Б. И., Солнце и атмосфера Земли, Л., 1976; Гордиенко Б. Ф., Марков М. И., Шелестов Л. А., Солнечная активность на Земле, М., 1980; М. И. Оршич и др., Солнечная активность и Земля, М., 1981; Сидякин В. Г. и др., Космическая экология, К., 1985; Комаров Ф. И. и др., Гелиогеофизические факторы и их воздействие на климатические процессы в биосфере, М., 1980.

СОЛНЕЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ — потоки ускоренных заряд. частиц, эпизодически появляющиеся в межпланетном пространстве на фоне галактических космических лучей (ГКЛ) после нек-рых солнечных вспышек. Способность Солнца испускать ускоренные частицы впервые обнаружена в 1942 С. Форбушем (S. Forbush) и др., зарегистрировавшими резкое увеличение потока частиц после солнечной вспышки. Факт ускорения частиц на Солнце подтверждается, помимо регистрации С. к. л. в межпланетном пространстве, наблюдениями рентг. и радиолучения Солнца, а также регистрацией γ -лучей и нейтронов, возникающих во время солнечных вспышек в результате ядерных реакций ускоренных частиц в атмосфере Солнца.



Рис. 4. Сопоставление периодов некоторых биологических макропроцессов с основными гармониками солнечной активности (СА) и магнитной возмущённости (МВ).

центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и кровотоковой систем человека, влияя на его общее состояние. Наиб. вероятной причиной такой реакции являются НЧ-колебания ал.-магн. поля Земли.

Электрич. состояние атмосферы также сильно меняется во времени и пространстве (в частности, под действием космич. лучей), причём осн. изменения в цепи *атмосферного электричества* между ионосферой и поверхностью Земли происходят, по-видимому, на высотах стратосферы и в тропосфере. Из-за близости этих оболочек к поверхности Земли роль атм. электричества очень важна (особенно в солнечно-тропосферных и солнечно-биосферных связях). Однако в нек-рых случаях (напр., в крупных городах и промышленных районах) связь между геомагн. колебаниями, электрич. состоянием атмосферы и биол. процессами может быть затуманена влиянием мощных эл.-магн. полей искусств. происхождения.

Триггерный (спусковой) механизм имеет особое значение для процессов в атмосфере Земли. Показано, в частности, что при вхождении Земли в усиленный поток солнечного ветра заметно меняется картина распределения приземного давления, растёт нестабильность тропосферы и изменяется интенсивность циркуляции, причём совокупность свойств этих явлений указывает на триггерный механизм их происхождения. Не исключено, что и др. атм. процессы (ураганы, циклоны и т. п.) на нек-рых этапах их формирования и развития подвержены слабым энергетич. воздействиям, обусловленным возмущениями в солнечном ветре и магнитосфере.

В научении механизмов С.-з. с. важное место занимает лаб. моделирование таких процессов, как солнечная вспышка (пересоединение магн. полей в плазме и ускорение частиц) или обтекание магнитосферы Земли солнечным ветром. Не меньший интерес представляют активные эксперименты в магнитосфере и ионосфере по моделированию эффектов, вызываемых солнечной активностью: нагрев ионосферы мощным радиолучением от наземного передатчика, инжекция электронов или ионных пучков с борта ИСЗ, выброс с борта ракет

ядра и электроны. Относит. содержание ядер в области энергий $E > (1-3) \cdot 10^7$ эВ совпадает с их распространённостью в солнечной короне (см. *Солнце*). В области меньших энергий потоки С. к. л. часто обогащены тяжёлыми ядрами. Наиб. заметные отклонения от состава солнечной атмосферы связаны с изотопом гелия ^3He . Зарегистрированы события с аномально большим содержанием ^3He в области энергий порядка кэВ. МэВ/нукл. в 10^3-10^4 раз превышает солнечное.

Поток С. к. л. состоит из частиц более низких по сравнению с ГКЛ энергий. Величина пороговой (минимальной) энергии, с к-рой начинается устойчивое ускорение частиц, не установлена. В межпланетном пространстве в С. к. л. наблюдаются электроны с мин. энергией 2 кэВ, в ядре — с энергией в десятки кэВ/нукл. Макс. наблюдающаяся энергия протонов С. к. л. $\approx 2 \cdot 10^{10}$ эВ (вспышка 23 февраля 1956). Во всём интервале наблюдаемых энергий спектр С. к. л. падающий, с более быстрым уменьшением числа частиц в области больших энергий. Обычно форма дифференц. спектров, измеренных в межпланетном пространстве, описывается степенной ф-цией E^{γ} . Характерная величина γ в событиях, когда измерены спектры наиб. близки к спектрам в источнике, составляет $2-4$ ($10 \leq E \leq 100$ МэВ).

Потоки С. к. л. меняются от вспышки к вспышке на нек-р. порядках величин. Частота появлений С. к. л. коррелирует с уровнем *солнечной активности* и в 11-летнем *солнечном цикле*. Циклы различаются по мощности генерации С. к. л. Наиб. активным был 19-й цикл (1954—64), когда суммарный поток протонов с $E > 10^7$ эВ составил $7,2 \cdot 10^{16}$ см $^{-2}$. В 20-м (1964—70) и 21-м (1976—

1986) пиках потоки С. к. л. были более слабыми — $\approx 2 \cdot 10^{10}$ см $^{-2}$. В настоящее, 22-м цикле вновь происходит сильная генерация С. к. л. Суммарный поток от событий, произошедших за 3 года (1989—91), достиг $\approx 5 \cdot 10^{10}$ см $^{-2}$. Второе по мощности событие наблюдалось 29 сент. 1991 (энергия протонов $> 10^{10}$ эВ). С начала непрерывных наблюдений (1956—91) на Земле зарегистрировано 48 событий с релятивистскими протонами $\phi \geq 10^9$ эВ. Случаи, когда на Солнце выбрасываются протоны меньших энергий ($\geq 10^7$ эВ), происходят гораздо чаще — от одного до неск. десятков в год, близких к максимуму солнечной активности. Ещё чаще после слабых вспышек регистрируются только потоки нерелятивистских электронов с энергией до 100—200 кэВ.

Механизм ускорения частиц на Солнце остаётся неясным; однако нек-рые характеристики «солнечного ускорителя» известны. Ускорение частиц происходит в импульсной фазе *вспышки на Солнце* в верх. хромосфере или в ниж. короне при плотности плазмы 10^{16} — 10^{13} см $^{-3}$, темп-ре 10^8 — 10^7 К и магн. поле порядка неск. сотен гаусс. Темп набора энергии быстрый, причём ускорение электронов до $\sim 10^7$ эВ и протонов до $\sim 10^8$ эВ может происходить практически одновременно в течение неск. секунд. Полное число ускоренных протонов с $\phi > 10^7$ эВ может достигать 10^{34} , а их суммарная энергия — 10^{31} эрг. На долю всех ускоренных частиц, в осн. протонов, приходится неск. процентов от полного энерговыделения во вспышке. Пока неясно, во всех ли достаточно энергичных вспышках происходит ускорение частиц. Из данных по γ -лучням следует, что бываю случаи ускорения частиц на Солнце, не сопровождающиеся адекватными потоками С. к. л. в межпланетном пространстве, и наоборот, иногда наблюдаются большие потоки С. к. л. после вспышек без γ -лучней. Отсутствие однозначной связи между числом ускоренных частиц и их частью, выходящей в межпланетное пространство, требует, очевидно, более детального исследования условий генерации и выхода частиц из области ускорения, а также процессов их распространения в межпланетном пространстве. Ускоренные на Солнце частицы анногируют гелиосферу (см. *Межпланетная среда*), двигаясь в регулярном межпланетном магн. поле (ММП) (см. в ст. *Солнечный ветер*) и рассеиваясь на его неоднородности. Характерный временной профиль С. к. л. имеет быстрый подъём и более плавный спад интенсивности, полная длительность возрастания порядка неск. часов для частиц больших энергий и десятков часов для менее энергичных частиц. Во мн. случаях такой профиль удовлетворительно описывается моделью аннотропной диффузии с импульсной или длительной ионизирующей. Иза- спиральной формы силовых линий ММП наб. благоприятными для наблюдения С. к. л. являются события от вспышек, происходящих вблизи основания силовой линии, соединяющей точку наблюдения с Солнцем. Для Земли это гелиодолгота Y 50° — 70° . С. к. л. являются одним из компонентов системы *солнечно-земных связей*. В частности, потоки С. к. л. падают в атмосферу Земли на высоких широтах, вызывают доплит. ионизацию ионосферы и нарушают радиосвязь. Интенсивные потоки С. к. л. в межпланетном пространстве — один из источников радиацион. опасности ири космич. полётах.

Лит.: С о ж о в В. В., С м р о в а т с к и я С. И., Физические процессы в атмосфере Солнца, называемые вспышками, «УФН», 1976, т. 120, с. 217; Исследования солнечной активности и космической системы «Прогноз». Сб. ст., под ред. Р. З. Сагдеева, М., 1984; Проблемы физики космических лучей. Сб. ст., под ред. А. В. Чуланова, М., 1987. А. И. Соловьев.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР — непрерывный поток плазмы солнечного происхождения, распространяющийся приблизительно радиально от Солнца и заполняющий Солнечную систему до гелиоцентра. расстояние $R \sim 100$ а. е. С. в. образуется при газодинамич. расширении солнечной короны (см. *Солнце*) в межпланетное пространство. При высоких темп-рах, к-рые существуют в солнечной короне ($\approx 1,5 \cdot 10^6$ К), давление вышележащих

слоёв не может уравновесить газовое давление вещества короны, и корона расширяется.

Первые свидетельства существования пост. потока плазмы от Солнца получены Л. Бирманом (L. Biermann) в 1950-х гг. по анализу сил, действующих на плазменные хвосты комет. В 1957 Ю. Паркер (E. Parker), анализируя условия равновесия вещества короны, показал, что корона не может находиться в условиях гидростатич. равновесия, как это раньше предполагалось, а должна расширяться, и это расширение при имеющихся граничных условиях должно приводить к разгону коронального вещества до сверхзвуковых скоростей (см. ниже). Впервые поток плазмы солнечного происхождения был зарегистрирован на советском космич. аппарате «Луна-2» в 1959. Существование пост. истечения плазмы из Солнца было доказано в результате многомерных измерений на амер. космич. аппарате «Маринер-2» в 1962.

Ср. характеристики С. в. приведены в табл. 1. Потоки С. в. можно разделить на два класса: медленные — со скоростью ≈ 300 км/с и быстрые — со скоростью 600—700 км/с. Быстрые потоки исходят из областей солнечной короны, где структура магн. поля близка к радиальной. Часть этих областей являются *корональными дырами*. Медленные потоки С. в. связаны, по-видимому, с областями короны, в к-рых имеется значит. тангенциальный компонент магн. поля.

Т а б л. 1.— Средние характеристики солнечного ветра на орбите Земли

Скорость	400 км/с
Концентрация протонов	6 см^{-3}
Температура протонов	$5 \cdot 10^4$ К
Температура электронов	$1,5 \cdot 10^4$ К
Направленность магнитного поля	$5 \cdot 10^{-4}$ Г
Плотность потока протонов	$2,4 \cdot 10^8 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$
Плотность потока ионизической энергии	$0,3 \text{ эрг} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$

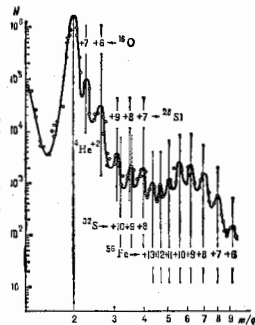
Т а б л. 2.— Относительный химический состав солнечного ветра

Элемент	Относительное содержание	Элемент	Относительное содержание
H	0,96	Ne	$7,5 \cdot 10^{-4}$
⁴ He	$1,7 \cdot 10^{-2}$	Si	$7,5 \cdot 10^{-4}$
¹⁶ O	$5 \cdot 10^{-4}$	Ar	$3,0 \cdot 10^{-4}$
		Fe	$4,7 \cdot 10^{-4}$

Помимо осн. составляющих С. в. — протонов и электронов, в его составе также обнаружены α -частицы, высокоионизов. ионы кислорода, кремния, серы, железа (рис. 1). При анализе газов, захваченных в экспонированных на Луне фольгах, найдены атомы Ne и Ar. Ср. относительный хим. состав С. в. приведён в табл. 2. Ионизаци. состояние вещества С. в. соответствует тому уровню в короне, где время рекомбинации мало по сравнению со временем расширения ($R = 1,5$ — $2 R_\odot$). Измерения ионизаци. темп-ры ионов С. в. позволяют определять электронную темп-ру солнечной короны.

В С. в. наблюдаются разл. типы волн: лонгитюдные, альвовские, ионно-звуковые, магнитозвуковые, альвовские и др. (см. *Волны в плазме*). Часть волн альвовского типа генерируется на Солнце, часть — возбуждается в межпланетной среде. Генерация волн приводит к отклонению ф-ции распределения частиц от максвелловской и в совокупности с воздействием магн. поля на плазму приводит к тому, что С. в. ведёт себя как сплошная среда. Волны альвовского типа играют большую роль в ускорении малых составляющих С. в. и в формировании ф-ции распределения протонов. В С. в. наблюдаются также контактные и вращательные разрывы, характерные для замагниченной плазмы.

Рис. 1. Массовый спектр солнечного ветра. По горизонтальной оси — отношение массы частицы к её заряду, по вертикальной — число частиц, зарегистрированных в энергетическом окне прибора на 10 с. Цифры со знаком «+» обозначают заряд иона.



Поток С. в. является сверхзвуковым по отношению к скоростям тех типов волн, к-рые обеспечивают эфф. передачу энергии в С. в. (альвовенские, звуковые и магнитоакустические волны). Альвовенские и звуковые Маха число С. в. на орбите Земли ≈ 7 . При обтекании С. в. препятствия, способных эффективно отклонять его (магн. поля Меркурия, Земли, Юпитера, Сатурна или проводящие ионосферы Венеры и, по-видимому, Марса), образуется отходящая головная ударная волна. С. в. тормозится и разогревается на фронте ударной волны, что позволяет ему обтекать препятствие. При этом в С. в. формируется полость — магнитосфера (собственная или индуцированная), форма и размеры к-рой определяются балансом давления магн. поля планеты и давления обтекающего потока плазмы (см. *Магнитосфера Земли, Магнитосферы планет*). В случае взаимодействия С. в. с непроводящим телом (напр., Луна) ударная волна не возникает. Поток плазмы поглощается поверхностью, а за телом образуется полость, постепенно заполняемая плазмой С. в.

На стационарный процесс истечения плазмы короны накладываются нестационарные процессы, связанные со вспышками на Солнце. При сильных вспышках происходит выброс вещества из ниж. областей короны в межпланетную среду. При этом также образуется ударная волна (рис. 2), к-рая постепенно замедляется, распространяясь в плазме С. в. Приход ударной волны к Земле вызывает сжатие магнитосферы, после к-рого обычно начинается развитие магн. бури (см. *Магнитные вариации*).

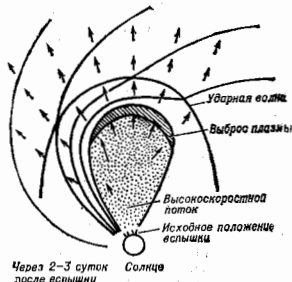


Рис. 2. Распространение межпланетной ударной волны и выброса от солнечной вспышки. Стрелками показано направление движения плазмы солнечного ветра, линии без подписей — силовые линии магнитного поля.

Расширение солнечной короны описывается системой уравнй сохранения массы, момента кол-ва движения и уравнения энергии. Решения, отвечающие разн. характеру изменения скорости с расстоянием, показаны на рис. 3. Решения 1 и 2 соответствуют малым скоростям в основании короны. Выбор между этими двумя решениями определяется условиями на бесконечности. Решение

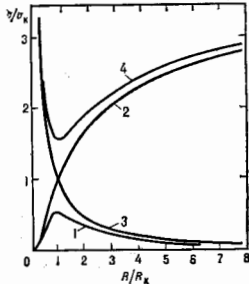


Рис. 3. Типы решений уравнения расширения короны. Скорость и расстояние нормированы на критическую скорость v_c и критическое расстояние R_c . Решение 2 соответствует солнечному ветру.

1 соответствует малым скоростям расширения короны и даёт большие значения давления на бесконечности, т. е. встречается с теми же трудностями, что и модель статич. короны. Решение 2 соответствует переходу скорости расширения через значения скорости звука (v/v_c) на нек-ром критич. расстоянии R_c и последующему расширению со сверхзвуковой скоростью. Это решение даёт исчезающе малое значение давления на бесконечности, что позволяет согласовать его с малым давлением межзвёздной среды. Течение этого типа Ю. Паркер назвал С. в. Критич. точка находится над поверхностью Солнца, если темп-ра короны меньше нек-рого критич. значения $T_K = GM_{\odot}m/4kR_{\odot}^2$, где m — масса протона, γ — показатель адiabаты, M_{\odot} — масса Солнца. На рис. 4 показано

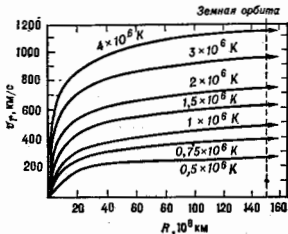


Рис. 4. Профили скорости солнечного ветра для модели изотермической короны при различных значениях нормальной температуры.

изменение скорости расширения с гелиоцентрич. расстоянием в зависимости от темп-ры изотермич. изотропной короны. Последующие модели С. в. учитывают вариации корональной темп-ры с расстоянием, двухжидкостный характер среды (электронный и протонный газы), теплопроводность, вязкость, несферич. характер расширения.

С. в. обеспечивает осн. отток тепловой энергии короны, т. к. теплопередача в хромосфере, эл.-магн. излучение короны и электронная теплопроводность С. в. недостаточны для установления теплового баланса короны. Электронная теплопроводность обеспечи-

вает медленное убывание темп-ры С. в. с расстоянием. С. в. не играет сколько-нибудь заметной роли в энергетике Солнца в целом, т. к. поток энергии, уносимый им, составляет $\sim 10^{-7}$ светимости Солнца.

С. в. увлечет с собой в межпланетную среду корональные магн. поле. Вмороженное в плазму силовое линии этого поля образуют межпланетные магн. поле (ММП). Хотя напряжённость ММП невелика и плотность его энергии составляет ок. 1% от плотности кинетич. энергии С. в., оно играет большую роль в термодинамике С. в. и в динамике взаимодействий С. в. с телами Солнечной системы, а также потоков С. в. между собой. Комбинация расширения С. в. с вращением Солнца приводит к тому, что магн. силовые линии, вмороженные в С. в., имеют форму, близкую к спирали Архимеда (рис. 5). Радиальная V_R и азимутальная V_ϕ компо-

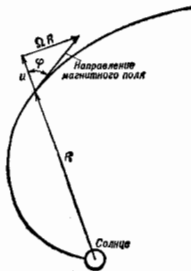


Рис. 5. Форма силовой линии межпланетного магнитного поля. Ω — угловая скорость вращения Солнца, v — радиальная компонента скорости плазмы, R — гелиоцентрическое расстояние.

ненты магн. поля по-разному изменяются с расстоянием вблизи плоскости эклиптики:

$$V_R \approx V_R^0 (R_0/R)^2, \quad V_\phi \approx V_\phi^0 R_0^2 \Omega / R u,$$

где Ω — угл. скорость вращения Солнца, v — радиальная компонента скорости С. в., индекс 0 соответствует исходному уровню. На расстояниях орбиты Земли угол ϕ между направлением магн. поля и R порядка 45° . При больших R магн. поле почти перпендикулярно R .

С. в., возникающий над областями Солнца с разл. ориентацией магн. поля, образует потоки с различно ориентированным ММП. Разделное наблюдаемой крупномасштабной структуры С. в. на чётное число секторов с разл. направлением радиального компонента ММП наз. межпланетной секторной структурой. Характеристики С. в. (скорость, темп-ра, концентрация частиц и др.) также в ср. закономерно изменяются в сечении каждого сектора, что связано с существованием внутри сектора быстрого потока С. в. Границы секторов обычно располагаются внутри медленного потока С. в. Чаще всего наблюдаются 2 или 4 сектора, вращающихся вместе с Солнцем. Эта структура, образующаяся при вытязании С. в. крупномасштабного магн. поля короны, может наблюдаться в течение неск. оборотов Солнца. Секторная структура ММП — следствие существования токового слоя (ТС) в межпланетной среде, к-рый вращается вместе с Солнцем. ТС создаёт скачок магн. поля — радиальные компоненты ММП имеют разные знаки по разные стороны ТС. Этот ТС, предсказанный Х. Альвеном (H. Alfvén), проходит через те участки солнечной короны, к-рые связаны с активными областями на Солнце, и разделяет указанные области с разл. знаками радиальной компоненты солнечного магн. поля. ТС распространяется приблизительно в плоскости солнечного экватора и имеет складчатую структуру. Вращение Солнца приводит к закручиванию складок ТС в спирали (рис. 6). Находясь вблизи плоскости эклиптики, наблюдатель оказывается то выше, то ниже ТС, благодаря чему попадает в секторы с разными знаками радиальной компоненты ММП.

Вблизи Солнца в С. в. существуют долготные и широтные градиенты скорости, обусловленные разностью скоростей быстрых и медленных потоков. По мере удаления от Солнца и укрупнения границы между потоками в С. в. возникают радиальные градиенты скорости,

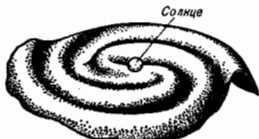


Рис. 6. Форма гелиоцентрического токового слоя. Пересечение его с плоскостью эклиптики (наклонённой и экватору Солнца под углом $\sim 7^\circ$) даёт наблюдаемую секторную структуру межпланетного магнитного поля.

к-рые приводят к образованию *бесстолкновительных ударных волн* (рис. 7). Сначала образуется ударная волна, распространяющаяся вперёд от границы секторов (прямая ударная волна), а затем образуется обратная ударная волна, распространяющаяся к Солнцу.



Рис. 7. Структура сектора межпланетного магнитного поля. Короткие стрелки показывают направление течения плазмы солнечного ветра, линии со стрелками — силовые линии магнитного поля, штрихпунктир — границы сектора (пересечение плоскости рисунка с токовым слоем).

Т. к. скорость ударной волны меньше скорости С. в., плазма увлекает обратную ударную волну в направлении от Солнца. Ударные волны вблизи границ секторов образуются на расстояниях ~ 1 а. е. и прослеживаются до расстояний в неск. а. е. Эти ударные волны, так же как и межпланетные ударные волны от вспышек на Солнце и околопланетные ударные волны, ускоряют частицы и являются, т. о., источниками энергичных частиц.

С. в. распространяется до расстояний ~ 100 а. е., где давление межзвёздной среды уравновешивает динамики. давление С. в. Плотность, заметная С. в. в межзвёздной среде, образует гелиосферу (см. *Межзвёздная среда*). Распространяясь С. в. вместе с вмороженным в него магн. полем препятствует проникновению в Солнечную систему галактич. космич. лучей малых энергий и приводит к вариациям космич. лучей больших энергий.

Явление, аналогичное С. в., обнаружено и у нейтр-ных др. звёзд (см. *Звёздный ветер*).

Лит.: П а р к е р Е. Н. Динамические процессы в межпланетной среде, пер. с англ., М., 1965; Б р а н д т Д. Ж. Солнечный ветер, пер. с англ., М., 1973; Х у н д х а у з е н А., Расширение короны и солнечный ветер, пер. с англ., М., 1976. О. Л. Байсберг.

СОЛНЕЧНЫЙ ЦИКЛ — периодический процесс появления и развития на Солнце активных областей — мест выхода на поверхность сильных магн. полей. Это процесс затрагивает весь диск Солнца и все уровни его атмосферы. Сильное всего *солнечная активность* проявляется в широтной зоне $\pm 30^\circ$. Центры активности появляются в нач. цикла на широтах ок. 30° , а затем зона, занятая ими, постепенно смещается к более низким широтам. Активные области часто объединяются в комплексы, группирующиеся около двух (реже — трёх) активных долгот. Последние сохраняются в течение неск. лет. От ср. широт к полюсам распространя-

ются эволюи активности — вытнутые по долготе цепочки протуберанцев и участки магн. полей умеренной напряженности. Их приход к полюсам в максимуме С. ц. приводит к обращению знака квазидипольного поля Солнца. В максимуме С. ц. хромосфера и корона становятся более плотными, в них появляются несколько больше горячих областей, гораздо богаче становится структура. Так, напр., *корональные лучи*, обычно развивающиеся в низких и средних широтах, могут появляться в близ полюсов.

С. ц. чаще всего отождествляют изменению с периодом $\approx 11,2$ года числа солнечных пятен (см. *Вольфа числа*). Приведенное значение периода является ср. значением, длительности конкретных циклов заключены в пределах 8—16 лет, подъем к максимуму происходит быстрее спада. Для объяснения С. ц. используют также величину потока радиационного излучения Солнца на определ. высоте (на практике на $\lambda = 10,7$ см).

Для данного цикла характерен определ. закон чередования полярностей магн. полей пятен. В фиксиров. полушарии западные (ведущие по отношению к вращению) пятна имеют одну полярность, замыкающие — другую. Возврат к одной и той же общей картине магн. полей на Солнце (знакам полярностей пятен и квазидипольного магн. поля) происходит примерно через 22 года. Иногда последнюю величину называют магн. циклом.

Лит. см. при ст. *Солнечная активность*. М. А. Лышчу.
СОЛНЦЕ.

Содержание:

1. Введение	589
2. Внутреннее строение	590
3. Атмосфера	592
4. Магнитные поля	593
5. Излучение	593

1. Введение

С. — газовый, точнее плазменный, шар. Радиус С. $R_{\odot} = 6,96 \cdot 10^{10}$ см, т. е. в 109 раз больше экваториального радиуса Земли; масса С. $M_{\odot} = 1,99 \cdot 10^{33}$ г, т. е. в 333000 раз больше массы Земли. В С. сосредоточено 99,866% массы *Солнечной системы*. Ср. плотность солнечного вещества $1,41$ г/см³, что составляет 0,256 ср. плотности Земли (солнечное вещество содержит по массе 68% водорода, 30% гелия и ок. 2% др. элементов). Ускорение свободного падения на уровне видимой поверхности С. $g = 2,7 \cdot 10^4$ см/с². Вращение С. имеет дифференц. характер: экваториальная зона вращается быстрее (14,4° за 1 сут.), чем высокоширотные зоны (10° за 1 сут. у полюсов). Ср. период вращения С. 25,38 сут. скорость вращения на экваторе ок. 2 км/с, энергия вращения (определяемая по вращению поверхности) составляет $2,4 \cdot 10^{43}$ эрг. Мощность излучения С. — его *светимость* $L_{\odot} \approx 3,85 \cdot 10^{33}$ эрг/с ($3,86 \cdot 10^{26}$ Вт). *Эффективная температура* поверхности $T_2 = 5830$ К. Солнце относится к звездам-карликам *спектрального класса G2*. На диаграмме спектр — светимость (см. *Герцшпрунга — Расселла диаграмма*) С. находится в ср. части гл. последовательности, на к-рой лежат стационарные звёзды, практически не изменяющие своей светимости в течение миллиардов лет. С. имеет 9 спутников-планет, суммарная масса к-рых составляет всего лишь 0,13%, но на них приходится ок. 98% момента кол-ва движения всей солнечной системы.

Под действием гравитации С., как и любая звезда, стремится сжаться. Этому сжатию противодействует перепад давления, возникающий из-за высокой темп-ры и плотности внутр. слоев С. В центре С. темп-ра $T \approx 1,6 \cdot 10^7$ К, плотность ≈ 160 г/см³. Столь высокая темп-ра в центр. областях С. может подпирать длительно только ядерными реакциями синтеза гелия из водорода. Эти реакции и являются осн. источником энергии С.

При темп-рах, характерных для центра С., осн. энергия излучения приходится на рентг. диапазон. Из центр. области С. до его поверхности ал.-магн. излучение из-за многократного поглощения и переизлучения доходит за время ~ 1 мин. лет, при этом спектр существенно изменяется (лучь, приближающуюся в 200 раз больше, — от С. до Земли — свет проходит за время ≈ 8 мин).

В отличие от фотонов, солнечные нейтрино, возникающие в результате ядерных реакций в центре С., доходят до нас практически не поглощаясь. Методы нейтринной астрономии подтверждают наши представления о ядерных реакциях в центр. областях С.

В недрах С. атомы (в осн. это атомы водорода) находятся в ионизов. состоянии. Если водород полностью ионизован, то поглощение излучения связано гл. обр. с отрывом электронов от ионов более тяжелых элементов (с их фотоионизацией). Однако таких элементов в недрах С. мало. Двигаясь из солнечных недр фотоны частично рассеиваются и поглощаются свободными электронами. Суммарное поглощение в ионизов. газе центр. области С. всё же относительно мало. По мере удаления от центра С. темп-ра и плотность газа падают, и на расстояниях, больших $0,7-0,8 R_{\odot}$, уже могут существовать нейтральные атомы (в более глубоких слоях — атомы гелия, ближе к поверхности С. — атомы водорода). С появлением нейтральных атомов (особенно многочисл. атомов водорода) резко возрастает поглощение, связанное с их фотоионизацией. Перенос энергии излучением сильно затрудняется. Выключается др. механизм переноса энергии — развиваются крупномасштабные конвективные движения, и лучистый перенос сменяется конвективным (см. *Конвективная неустойчивость*). Протяженность по высоте солнечной конвективной зоны ≈ 200 тыс. км ($\approx 0,3 R_{\odot}$). Скорости конвективных движений в глубоких слоях малы — порядка 1 м/с, в тонком верх. слое они достигают 2 км/с.

Выше, в самых поверхностных слоях С., энергия вновь переносится излучением. Излучение, приходящее от С. к внеш. наблюдателю, возникает в чрезвычайно тонком поверхностном слое — фотосфере, имеющей толщину $(1/2000) R_{\odot} \approx 350$ км. Располагающаяся над фотосферой хромосфера и корона практически свободно пропускают непрерывное оптич. излучение фотосферы (ближайке к излучению абсолютно чёрного тела с темп-рой ок. 6000 К). Верх. часть фотосферы и переходную область между фотосферой и хромосферой иногда называют *обращающим слоем*. Этот слой прозрачен для частот непрерывного спектра. Однако в нек-рых частотах, определяемых строением образующей слой атомов, слой непрозрачен. Излучение на этих избранных частотах рассеивается или поглощается *обращающим слоем*, и в спектре появляются линии поглощения, к-рые иногда называют *фрагментовыми линиями*. Практически вся энергия излучения Солнца заключена в непрерывном излучении фотосферы, приходящем на интервал длин волн от 1500 Å до 0,5 м.

В радиодиапазоне и КВ-области спектра излучение существенно отличается от фотосферного. В радиодиапазоне оно остаётся непрерывным, однако его *экстремальная температура* T_2 начинает возрастать: в миллиметровом диапазоне $T_2 \approx 6000$ К, при $\lambda = 1$ см $T_2 \approx 10000$ К и монотонно возрастает до 10^6 в диапазоне от 3 до 100 см. Это объясняется тем, что внешние разреженные части солнечной атмосферы — хромосфера и корона, прозрачные для видимого света, оказываются непрозрачными в радиодиапазоне и с увеличением длины радиоволн излучение поступает к нам от всё более высоких и более горячих уровней атмосферы. Интенсивность радиоволнового излучения и корона испытывает значит. изменения, как медленные, так и более быстрые (испески). Последние связаны с нелетельными плазменными процессами.

При темп-рах $\sim 10^4$ К (хромосфера) и 10^6 К (корона), а также в переходном слое с промежуточными темп-рами появляются ионы разл. элементов. Соответствующие этим зонам эмиссионные линии довольно многочисленны в КВ-части спектра ($\lambda < 1800$ А). Спектр в этой области состоит из отд. эмиссионных линий, самые яркие из к-рых — линия водорода L_{α} (1216 А), и линия нейтрального (584 А) и ионизованного (304 А) гелия. Излучение в этих линиях выходит из области эмиссии практически не поглощаясь. Излучение в радио- и рентг. областях сильно зависит от степени *солнечной активности*, увеличиваясь или уменьшаясь в неск. раз в течение 11-летнего солнечного цикла и заметно возрастая при *вспышках на Солнце*.

Физ. характеристики разл. слоев приведены на рис. 1 (условно выделена ниж. хромосфера толщиной 1500 км, где газ более однороден). Нагрев верх. атмосфер С. (хромосферы и короны) может быть объяснен механ. энергией, переносимой волнами, возникающими в верх. части конвективной зоны, и

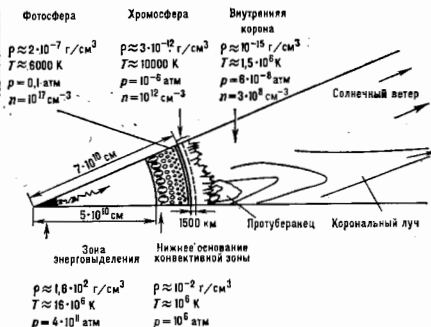


Рис. 1. Физические характеристики слоев Солнца: ρ — плотность, T — температура, p — давление, n — число частиц в 1 см³. Толщина фотосферы и хромосферы на рисунке несколько преувеличена.

диссипацией (поглощением) энергии электрич. токов, генерируемых магн. полями.

С существованием на С. поверхностной конвективной зоны связан ещё ряд явлений. Ячейки самого верх. яруса конвективной зоны наблюдаются на поверхности С. в виде гранул. Более глубокие крупномасштабные движения во 2-м ярусе зоны проявляются в виде ячеек сверхгрануляции и хромосферной сетки. Имеются основания считать, что конвекция в ещё более глубоком слое наблюдается в виде гигантских структур — ячеек с большими, чем сверхгрануляция, размерами.

Большие локальные магн. поля в зоне $\pm 30^\circ$ от экватора приводят к развитию т. н. активных областей с входящими в них пятнами. Число активных областей, их положение на диске и полярности пятен в группах меняются с периодом $\approx 11,2$ года. В период необычайно высокого максимума (1957—58) активность затрагивала практически весь солнечный диск. Кроме сильных локальных полей на С. имеется более слабое крупномасштабное магн. поле. Это поле меняет знак с периодом ок. 22 лет и близ полюсов обращается в нуль в максимуме солнечной активности. М. А. Лышич.

2. Внутреннее строение

Элементы тяжелее гелия составляют ок. 0,1% (по числу атомов) и присутствуют на С. примерно в тех же

пропорциях, что и на Земле. Это свидетельствует об их общем происхождении (см. *Происхождение Солнечной системы*). Геологич. данные, основанные на свойствах радиоактивных элементов в земной коре, показывают, что Земля отвердела $4,5 \cdot 10^9$ лет назад. Следовательно, и возраст С. должен быть больше. Известно также, что поток энергии от Солнца не изменился существенно за последние 10^9 лет.

Светимость С. обеспечивается энергией, освобождающейся в термоядерных реакциях превращения водорода в гелий, к-рые протекают в его центральной, наиб. горячей области — ядре. Термоядерный источник способен поддерживать С. в равновесном, почти неизменном состоянии длит. время — ок. 10^{10} лет; при отсутствии этого источника С. могло бы светить лишь за счёт собств. гравитацион. энергии, освобождающейся при медленном сжатии, но только в течение времени порядка $(GM^2/R_0)/L_0 \approx 3 \cdot 10^7$ лет.

Превращение водорода в гелий происходит гл. обр. в *водородном цикле* и частично в *углеродно-азотном цикле*. В конце этих циклов группы из четырёх протонов превращаются в ядра гелия. Поскольку масса ядра гелия меньше суммарной массы исходных протонов на 0,7%, то в каждом цикле выделяется энергия $\mathcal{E} = 0,007 \cdot (4m_p c^2) \approx 26,7$ МэВ (m_p — масса протона) в виде γ -излучения ($\approx 26,2$ МэВ) и двух нейтрино ($\approx 0,5$ МэВ). Нейтрино очень слабо взаимодействуют с веществом и поэтому почти беспрепятственно выходят из солнечного ядра. Фотоны же эффективно поглощаются и переизлучаются веществом. Длина свободного пробега фотонов (λ) в центр. областях С. $\sim 10^{-3}$ см. В результате излучение находится почти в термодинамич. равновесии с веществом. Это означает, что ср. энергия фотонов равна тепловой энергии частиц.

Перенос излучения наружу носит диффузионный характер, при к-ром фотоны многократно поглощаются и переизлучаются. Величина потока лучистой энергии внутри С. прямо пропорциональна градиенту темп-ры и обратно пропорциональна коэф. непрозрачности $\kappa = 1/\rho \mu$ (ρ — плотность вещества), характеризующему способность газа поглощать и рассеивать излучение. Однако не на всём пути от центра к поверхности солнечная энергия переносится излучением. На расстоянии примерно $0,7 R_0$ от центра вещество становится конвективно неустойчивым, и выше этого уровня энергия переносится преим. турбулентными потоками вещества. В конвективной зоне темп-ра невелика по сравнению с темп-рой ядра. В результате увеличивается число электронов, находящихся в связанных состояниях в атомах водорода и др. элементов. Это ведёт к увеличению непрозрачности газа, большому сопротивлению диффузии излучения и возрастанию градиента темп-ры. Конвективная неустойчивость наступает, если абс. значение градиента темп-ры станет больше нек-рой критич. величины, называемой адiabатич. градиентом. Скорости конвективных потоков возрастают по мере продвижения к поверхности от $\sim 10^3$ см/с до 10^4 см/с. Вблизи поверхности С. на расстоянии $0,999 R_0$ эффективность конвективного теплопереноса резко падает вследствие низкой плотности вещества. Здесь энергия вновь переносится излучением. Вероятно, этот верх. слой конвективной зоны ответствен за наблюдаемую грануляц. структуру поверхности С.

Эволюция С. определяется изменением его хим. состава в результате термоядерных реакций. Согласно расчётам, ныне в ядре доля водорода по массе ок. 35%, тогда как в начале эволюции, судя по поверхностным слоям, в к-рых термоядерные реакции не происходят, водород составлял ок. 73%. Превращение водорода в гелий постепенно увеличивает ср. молекулярный вес вещества, поэтому равновесие в солнечном ядре поддерживается при всё более высоких темп-ре и плотности. Поскольку скорости термоядерных реакций быстро увеличиваются с ростом темп-ры, те, пе-

смотря на уменьшение содержания водорода, выделенные энергии внутри С. возрастает. Следовательно, с возрастом светимость С. несколько увеличивается. В ходе эволюции центр ядра сжимается, а оболочка расширяется; радиус С. при этом растёт.

Теория внутр. строения эволюции звезд предсказывает, что, когда С. достигнет возраста 9-10¹⁰ лет, водород в центре ядра будет исчерпан и термоядерные реакции будут идти в окружающем ядре слое, к-рый расширяется со временем. На этой стадии эволюции длительность $\approx 5 \cdot 10^8$ лет существенно увеличится радиус С. и уменьшится эфф. темп-ра поверхности — С. станет красным гигантом (см. Красные гиганты и сверхгиганты). Затем последует выстрел газа ($\approx 5 \cdot 10^7$ лет) горения гелия и более тяжёлых элементов, сопровождающаяся сбросом оболочки, после чего С. превратится в медленно остывающий белый карлик.

Для детального изучения внутр. строения С. строят модели С. и сравнивают их предсказания с данными наблюдений. Стандартная модель С. рассчитывается при следующих предположениях: С. является сферически-симметричным и находится в гидростатич. равновесии; С. находится в состоянии теплового равновесия, за исключением небольших изменений энтропии во время эволюции; изменения хим. состава обусловлены ядерными реакциями в водородном и углеродно-азотном циклах; вещество перемешивается только в конвективной зоне; С. было первоначально однородным по хим. составу и эволюционировало без изменения массы в течение 4,7-10¹⁰ лет к совр. значениям радиуса и светимости.

Ур-ния, описывающие стандартную модель в перемен-ной $M_r = 4\pi \int_0^r \rho^2 dr$ (масса внутри радиуса r), имеют вид:

$$\frac{\sigma r}{\sigma M_r} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho};$$

$$\frac{\sigma P}{\sigma M_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^2} \quad (\text{условие гидростатич. равновесия});$$

$$\frac{\sigma L}{\sigma M_r} = \varepsilon - T \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} \quad (\text{ур-ние теплового баланса});$$

$$L = L_{\text{луч}} + L_{\text{ионв}} = 4\pi r^2 \left(-4\pi r^2 \rho K \frac{\partial T}{\partial M_r} - N u \cdot K \frac{\Delta T}{l} \right)$$

(ур-ние теплопереноса в диффузионном приближении для лучистого переноса и в приближении пути перемешивания для конвективного переноса). Здесь P — давление, ε — кол-во энергии, выработаемое 1г вещества в 1 с, S — энтропия единицы массы, $K = 160 \text{ ТДж/Змр} = \text{коэф. лучистой теплопроводности}$, σ — постоянная Стефана — Больцмана, $N u$ — число Нуссельта, характеризующее эффективность конвективного теплопереноса, ΔT — характерный перепад темп-р в конвективных элементах; l — длина перемешивания, к-рая полагается пропорциональной шкале (характерной высоте) изменения давления H_p . К этим ур-ниям добавляются ур-ние состояния $\rho = \rho(P, T, X_i)$, $S = S(P, T, X_i)$, выражения для коэф. поглощения $\kappa = \kappa(P, T, X_i)$ и скорости генерации энергии $\varepsilon = \varepsilon(P, T, X_i)$, где X_i — относит. содержание по массе элементов с атомным номером i . Ур-ния состояния в первом приближении такие же, как для идеального газа, но с учётом ионизации и возбуждения атомов, частичного вырождения электронного газа и электростатич. взаимодействия заряд. частиц. Для коэф. поглощения берётся среднее по частотам излучения значение. Скорость генерации энергии определяется вкладом отд. реакций водородного цикла и небольшой добавкой от реакций углеродно-азотного цикла. Ур-ния для изменения содержания элементов имеют вид:

$$\frac{1}{A_i} \frac{\partial X_i}{\partial t} = \sum_j \frac{X_j}{A_j} P_{ij} - \frac{X_i}{A_i} \sum_k P_{ik}$$

где $P_{ij} = \sum_{\nu} N_{\nu} \langle \sigma'_{\nu} \rangle_{ij}$ — вероятность на единицу времени образования ядра j из ядра i , $\langle \sigma'_{\nu} \rangle_{ij}$ — вероятность реакции синтеза $i + \beta \rightarrow j$, σ' — сечение этой реакции, ν — относит. скорость частиц i и β , угл. скобки означают усреднение, $N_i = N_{\nu} X_i / A_i$ — концентрация частиц i , N_A — число Авогадро, A_i — атомная масса. В расчётах вероятностей ядерных реакций учитываются поправки на электронное экранирование кулоновского потенциала ядер.

Ур-ния дополняются четырьмя граничными условиями. Поверхность модели соответствует эфф. темп-ре С., $T = T_s$, поэтому первое граничное условие: $4\pi r^2 \sigma T^4 = L$ при $M_r = M_{\odot}$. Второе условие на поверхности получается из равенства давления P при $M_r = M_{\odot}$ давлению, полученному путём интегрирования ур-ния гидростатич. равновесия в атмосфере. Два других граничных условия задаются в центре С. при $M_r = 0$: $r = 0$ и $L = 0$.

Эволюц. последовательности моделей С. рассчитываются начиная от стационарной, однородной по хим. составу модели, соответствующей нулевому возрасту на гл. последовательности, до модели совр. возраста $t_0 = 4,7 \cdot 10^9$ лет, принимая во внимание изменения хим. состава, вызванные ядерными реакциями (см. Моделирование звезд). Варированием двух параметров: нач. содержания гелия X_4 и $\alpha = l/H_p$ получают для $t = t_0$ модели, радиус и светимость к-рой согласуются с наблюдаемыми величинами. Некоторые характеристики стандартной модели приведены в табл. 1, 2 и на рис. 2.

Табл. 1. — Параметры Солнца согласно стандартной модели (Bahcall et al., 1982)

Светимость (L_{\odot})	3,86 · 10 ³³ эрг/с
Масса (M_{\odot})	1,99 · 10 ³³ г
Радиус (R_{\odot})	6,96 · 10 ¹⁰ см
Возраст (t_{\odot})	4,7 · 10 ⁹ лет
Плотность в центре (ρ_c)	158 г/см ³
Температура в центре (T_c)	15,5 · 10 ⁷ К
Содержание водорода по массе на поверхности (X_1)	0,732
Содержание водорода по массе в центре (X_{1c})	0,355
Эффективная температура поверхности (T_s)	5,78 · 10 ⁴ К
Начальное содержание гелия по массе (X_4)	0,25 ± 0,01
Начальное содержание тяжёлых элементов по массе (Z)	0,018
Глубина конвективной зоны	0,27 R_{\odot} ($M_r = 0,02 M_{\odot}$)
Доля энергии водородного цикла	0,985
Доля энергии углеродно-азотного цикла	0,015
Поток нейтрино от P-P-реаций	6,1 · 10 ¹⁰ см ⁻² · с ⁻¹ · 9
Поток нейтрино от реакции распада ядер ⁸ B	5,6 · 10 ⁸ см ⁻² · с ⁻¹ · 9

Табл. 2. — Параметры стандартной модели Солнца в зависимости от времени (Bahcall et al., 1982)

$t \cdot 10^{-10}$, лет	$R \cdot 10^{-10}$, см	$L \cdot 10^{-33}$, эрг/с	$T_s \cdot 10^{-4}$, К
0,000	6,07	2,68	5,85
0,525	6,17	2,81	5,67
1,575	6,32	3,05	5,71
3,155	6,50	3,40	5,75
4,735	6,96	3,88	5,78

Тестом для моделей С. являются данные о внутр. строении С., полученные путём измерения потока солнечных нейтрино и в результате наблюдений глобальных осцилляций С.

Электронные нейтрино с энергиями $\varepsilon > 0,81$ МэВ, образующиеся в реакции ${}^8\text{B} \rightarrow {}^8\text{Be} + e^+ + \nu_e$ водородного цикла, зарегистрированы в эксперименте Двай-

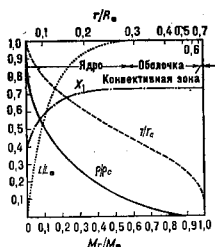


Рис. 2. Стандартная модель внутреннего строения Солнца (Васильев *et al.*, 1982). Плотность ρ , температура T , светимость L и содержание водорода по массе X , представлены как функции радиуса r и массы M_r .

са (см. *Нейтринная астрофизика*). Измеренный поток нейтрино оказался существованием меньшим величины $7,8 \pm 0,9 \text{ SNU}$ ($1 \text{ SNU} = 10^{-26}$ захватов нейтрино на одну частицу детектора в 1 с — солнечная нейтринная единица), предсказанной на основе стандартной модели. Расхождение может быть связано как с неточностью описания внутр. строения С. стандартной моделью, напр. в случаях перемешивания вещества в солнечном ядре в ходе эволюции или поиж. содержания тяжёлых элементов в зоне лучистого переноса, так и с превращением электронных нейтрино в мюонные в результате слабого взаимодействия при распространении в плотном солнечном веществе (эффект Михеева — Смирнова). Разрешить проблему дефицита солнечных нейтрино можно путём регистрации низкоэнергичных нейтрино ($E \leq 0,5 \text{ MeV}$), образующихся в первой реакции водородного цикла $p + p \rightarrow \text{D} + e^+ + \nu_e$, при помощи галлиевого детектора. Их поток (согласно расчётам, $\approx 107 \text{ SNU}$) практически не зависит от деталей внутр. строения С., и поэтому, если измеренная величина окажется меньше расчётной, то это будет подтверждением гипотезы превращения нейтрино. В противном случае малый поток высокоэнергичных нейтрино связан с отличиями от стандартной модели, и тогда для их выяснения потребуются дополнительные нейтринные эксперименты с разл. детекторами.

Измерения частот акустич. мод собств. колебаний С. показали, что строение оболочки ($0,3 \leq r/R_{\odot} \leq 0,4$) хорошо описывается стандартной моделью. Надёжных данных о структуре ядра пока не получено (см. *Солнечная сейсмология*).

Лит.: Солт, J. P., Guili, R. T., Principles of stellar structure, v. 1—2, N. Y.—L.—P., 1968; Гибсон Э., Спокойное Солнце, пер. с англ., М., 1977; Василл J. N. и др., Standard solar models and the uncertainties in predicted capture rates of solar neutrinos, «Rev. Mod. Phys.», 1982, т. 54, р. 767; Василл J. N. и др., Chlorine and gallium solar neutrino experiments, «Astrophys. J.», 1985, v. 292, p. L78; Мхеев С. П., Смирнов А. Ю., Осцилляции нейтрино в среде с переменной плотностью, «УФН», 1986, т. 150, в. 4, с. 632. А. Г. Косовичев.

3. Атмосфера

В атмосфере С., так же как и в атмосфере др. выродженных звёзд (см. *Звёздные атмосферы*), выделяют три слоя: фотосферу, хромосферу (см. также *Хромосферные звёзды*) и корону (см. *Солнечная корона, Корона звёзд*). Наблюдаемое непрерывное излучение в оптич. диапазоне генерируется в слое протяжённостью ок. 300 км — солнечной фотосфере. Оно является тепловым и достаточно точно описывается в видимой и близкой ИК-области спектра ф-цией Планка с эфф. темп-рой $T_e = 5830 \text{ K}$. Темп-ра в фотосфере падает с высотой, что приводит к наблюдаемому потемнению диска С. к краю (где видны поверхностные слои), несомненно — в красных лучах и более сильною — в синих и ультрафиолетовых. Небольшие флуктуации темп-ры спокойной фотосферы в горизонтальном направлении связаны, вероятно, с проникновением в эти слои горячего газа — поднимающихся из более глубоких слоёв конвективных потоков. Это солнечная грануляция — яркие ячейки неправильной формы (гранулы) диамет-

ром ок. 1—2" (700—1400 км вдоль поверхности С.) с более тонкими тёмными промежутками между гранулами.

Плазма солнечной фотосферы с плотностью ок. 10^{17} см^{-3} является слабоионизованной (рис. 3). Падение темп-ры с высотой на нек-ром уровне останавливается;

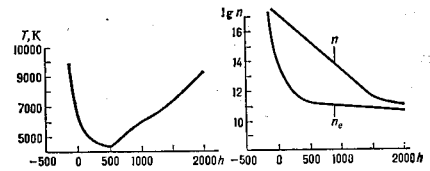


Рис. 3. Распределение температуры T , концентрации нейтрального водорода n и свободных электронов n_e в фотосфере и нижней хромосфере (h — высота в км).

выше этой т. н. области температурного минимума — выше атмосферы С. — темп-ра разреженного газа вновь возрастает до $\sim 10^4 \text{ K}$ в хромосфере и более чем до $\sim 10^6 \text{ K}$ в короне. Первые две тысячи км хромосферы остаются сравнительно однородной: лишь часть плазмы оказывается заключённой в петельные структуры; выше хромосферы распадается на ряд отд. потоков — хромосферных спикул, достигающих высот 8—40 тыс. км. Диаметры спикул сравнимы с диаметрами гранул, скорость подъёма и отсуска вещества в них $\approx 20 \text{ км/с}$.

Хромосфера с $T \approx 10000 \text{ K}$ является источником линейчатого излучения металлов, водорода и гелия. Линии наблюдаются в излучении за краем диска и в поглощении — в проекции на диск. Горизонтальная неоднородность хромосферы проявляется при наблюдениях в частотах линий H , водорода, H и K ионизов. кальция и нек-рых других. Наб. характерной является хромосферная сетка: ячейки diam. 20—30 тыс. км, покрывающие весь диск. Газ в ячейках растекается от центра к периферии со скоростями 0,3—0,4 км/с. Происхождение хромосферной сетки связано с наличием конвективных движений масштаба — супер-, или сверхгрануляции. На границ хромосферной сетки выбрасывается большее кол-во спикул, чем из центр. части ячеек.

Переход от хромосферного газа с $T \sim 10^4 \text{ K}$ к корональному с $T \sim 10^6 \text{ K}$ происходит в каждой фиксиров. точке поверхности С. очень резко, на промежуток высот всего 10—100 км. Такой узкий слой формируется за счёт потока тепла из короны вниз.

Над хромосферой располагается оболочка разреженного горячего газа (корона). В первом приближении плотность газа падает при удалении от лимба по гидростатич. закону (с уменьшением плотности в e раз на расстоянии ок. $0,1 R_{\odot}$). Плотности в основании короны изменяются от $\sim 10^8 \text{ см}^{-3}$ в активных и до $6 \cdot 10^7 \text{ см}^{-3}$ в самых разреженных участках, т. е. корональных дырах.

Оси. часть вещества короны сосредоточена во внутр. короне (до расстояний $0,1—0,3 R_{\odot}$ от лимба), причём ее равномерно, а в отдельных корональных петлях (арках). Самые плотные и горячие арки располагаются в активных областях и близ них. Длина петель L , давление плазмы и темп-ра б/в вершинах связаны в первом приближении т. н. соотношением подобия $T \sim (pL)^{1/2}$. Темп-ра плазмы в большинстве арки составляет 2 млн. К, плотности близки к 10^8 см^{-3} . Как само происхождение арочной структуры, так и нагрев плазмы в арках связаны с влиянием магн. полей.

В нек-рых плоскостях на С. атмосфера на всех высотах заметно отличается от описанной выше атмосферы спокойной С. Само появление центров активности, или активных областей, происходит с определ. последовательностью во времени и по местоположению на С.

Темп-ра верх. части фотосферы активной области повышается на 100—300 К, более яркие гранулы объединяются в цепочки, хорошо видимые при их приближении к краю диска (факелы). Факелы часто окружают солнечные пятна (рис. 4), состоящие из темной



Рис. 4.

и более близкой по яркости к фотосфере волокнистой полутьны. Темп-ра тени пятен примерно на 1500 К ниже фотосферной. Хромосфера активной области — флюкку (яркое образование в свете центра сильных линий H_{α} , H и K Ca II) иногда оказывается пересеченной системой темных волоконцев — фибрилл. Усиление яркости флюккула связано в осн. с повышением здесь плотности до 3 раз.

В корональной конденсации число арок заметно возрастает. Обычная, или перманентная, корональная конденсация ($n \geq 10^9$ см $^{-3}$, $T \approx 2 \cdot 10^6$ К, $D \leq 25^{\circ}$) существует над большими центром активности всё время его жизни, т. е. до года. Неск. суток наиб. интенсивного развития центра активности в большинстве случаев являются экстремальными и для корональной конденсации плотности в арках достигают 10^{10} см $^{-3}$, темп-ра в пек-рых из них повышается в неск. раз, развиваются сложные газодинамич. движения.

Кроме описанных выше стационарных образований в определ. моменты времени наблюдаются нестационарные явления, развивающиеся в короне и хромосфере. При солнечных вспышках газ в арочных системах нагревается до 20—30 млн. К, плотность повышается до 10^{10} см $^{-3}$. В ряде случаев наблюдается выброс плазмы на расстояние до сотен радиусов С. (корональные транзиты). В горячей короне иногда появляются холодные плотные облака ($n = 10^{10-16}$ — 10^{13} см $^{-3}$, $T \sim 10^4$ К) — солнечные протуберанцы.

4. Магнитные поля

На С. существует весьма сложная система магн. полей, изменяющаяся как во времени, так и в пространстве. В течение ряда лет величин минимума цикла активности высокие широты заполнены преим. слабыми полями одного знака (направления нормальной составляющей). В северном N и южном S полушариях знаки поля равны, так что картина там напоминает распределение полей диполя, помещенного в центр С. Каждые ≈ 11 лет происходит смена знака высокоширотных полей — переполюсовка диполя.

На более низких широтах $|\varphi| < 65^{\circ}$ также встречаются области, занимающие до $\sim 50^{\circ}$ по широте и долоте, преим. заполненные магн. образованиями одного знака. Ср. напряженность этих униполярных полей сравнима с той, к-рая характерна для высоких широт — ок. 1 Э.

Локальные магн. поля появляются в областях диам. 100—300 тыс. км на широтах менее 35° и вызывают весь комплекс явлений, развивающихся в центре активности. Часто они представляют собой два «холма» поля противоположной полярности напряженностью от сотен до тысяч эрстед. Наблюдается также мультиполярная структура этих образований. Если напряженность поля в «холме» превышает 1400 Э, на фотосфере появляется темное образование — пра, для полей $2-4$ тыс. Э — явто. Поля в центр. части явто — их тени — выходят примерно по нормали к поверхности, вне теня

(в окружающем пятно факеле) быстро становятся практически горизонтальными. Магн. поток центра активности ср. размеров или большой группы пятен близок к 10^{18} Мкс, сильно развитого пятна — к 10^{21} Мкс.

Высок. магн. потока на поверхность наблюдается в виде лебединых областей вспылавающего потока. Весь процесс занимает от одного до неск. дней и происходит внутри или на периферии уже существующих активных областей либо на участках спокойного С. Область вспылавающего потока биополярна и представляет собой систему протяженных (до 30000 км) низких (высотой до 5000 км) арок. Самые малые из таких образований, называемые эфемерными областями, примерно за сутки проявляются и исчезают; магн. поток каждой из них $\approx 10^{10}$ Мкс. На диске в течение суток может появиться до 100 таких эфемерных областей, по-видимому, проявляющихся в виде ярких рентг. точек; в рядку с центрами активности они вносят заметный вклад в общий магн. поток соответствующих крупномасштабных образований солнечной поверхности.

Полюсные поля невозмущенного С. сосредоточены в отд. элементах с магн. потоками $\geq 10^{14}$ Мкс. Поток неск. сосредоточен на границах ячеек хромосферной сетки. Магн. поток $\approx 3 \cdot 10^{17}$ Мкс при диаметре элемента 2000 км соответствует напряженности поля 10 Э. Внутри ячеек также встречаются элементы поля, чаще, чем на границах сетки, имеющие биополярную структуру (т. е. типа эфемерных областей). Усиление поля на границах сетки, по-видимому, связано с тем, что горизонтальные движения плазмы сгребают силовые линии к границам супергранулад, ячеек.

Все осн. явления, происходящие в активной области, обусловлены влиянием магн. поля на строение солнечной атмосферы. Так, уменьшение темп-ры пятен, вероятно, связано с тем, что вертикальные магн. поле затрудняет горизонтальные движения в конвективной ячейке. Поток энергии, переносимой коллекцией, при этом уменьшается, что и приводит здесь к некому охлаждению вещества.

Арочные структуры в хромосфере, и особенно во внутр. короне, обусловлены тем, что некр-ые пучки силовых линий заполнены плазмой. При увеличении нагрева в вершине арки поток тепла из-за высокой теплопроводности короны очень быстро проходит вдоль силовых линий и значительно повышает темп-ру части хромосферного вещества вдоль оснований арки. Это вещество расширяется вдоль силовых линий, заполняя всю арку. Соответствующий процесс испарения наблюдается при импульсном выделении энергии в короне в начале вспышек. При этом скорости отлетающего из хромосферных слоев нагретого до $T \sim 2 \cdot 10^7$ К газа составляют 300—400 км/с. Ударная волна с вздучением, идущая вниз, формирует слой плотного газа с $T = 8000-9000$ К — источник низкотемпературного свечения во вспышках.

Газодинамич. расширение короны в крупномасштабном квазидипольном поле С. приводит к формированию регулярного межпланетного магн. поля; появлению двух противоположно направленных магн. потоков с токовым слоем между ними. Ряд факторов вызывает гофрировку этого токового слоя. Пересечение Землей или космич. аппаратом токового слоя объясняет наблюдаемое явление секторной структуры межпланетного магн. поля (см. *Солнечный ветер*).

5. Излучение

Кол-во энергии, излучаемой с 1 м 2 поверхности С. в 1 с, равно 6,28·10 27 Вт. На ср. расстоянии Земли от С. (1 а. е.) поток излучения С. $\approx 1,37 \cdot 10^8$ Вт/м 2 (*солнечная постоянная*).

Развитие внеатмосферных методов наблюдений позволило изучить спектр С. во всем диапазоне эл. магн. волн — от γ -диапазона до километровых радиоволн. Осн. компонент солнечного излучения — непре-

рывное тепловое излучение фотосферы. Его спектр в первом приближении аналогичен спектру абсолютно чёрного тела с темп-рой ок. 6000 К (рис. 5). Это излучение простирается от 180 нм до 1 см, с максимумом ок. 450 нм. В нём заключена осн. часть энергии, излучаемой С. Поскольку темп-ра газа в фотосфере медленно

вк-ре присутствует ряд фраунгоферовых линий и молекулярных полос. Наблюдаются также неск. линий хромосферы (гелия, $\lambda = 1083,0$ нм, папюновские линии водорода, линии магния, а также нек-рые корональные линии). Суммарный поток ИК-излучения с длиной волны $\lambda \geq 0,8$ мкм составляет более 30% всего потока

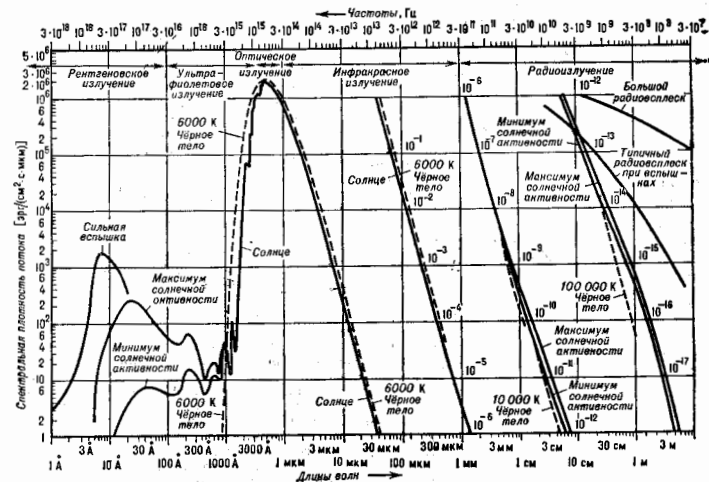


Рис. 5. Спектр излучения Солнца. Непрерывные линии — результаты измерений, штриховые — распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела с температурой $T = \approx 6000$ К (для $\lambda = T = 10^4$ и 10^5 К в ДВ-части спектра). Для волн длиннее 30 мкм порядки величин потоков указаны отдельно (близ кривых).

убывает с высотой, на края диапазона (ок. 200 нм и ок. 20–50 мкм) спектр излучения несколько более крутой, соответствующий темп-ре верх. фотосферы (≈ 4500 К).

Солнечное излучение во всех диапазонах подвержено влиянию солнечной активности. В видимой и близкой ИК-областях спектра отстоит. изменения потока излучения с характерными временами порядка суток и месяцев составляет всего 0,1–0,3%. Такова же и общая амплитуда изменений в течение 11-летнего цикла. На излучение в др. диапазонах, возникающее не в фотосфере, а в хромосфере и короне, активность влияет гораздо сильнее. Появляется перем. часть излучения, долящаяся на медленно изменяющуюся и вспыхивающую составляющие. Излучение первой из них — доплит. эмиссия, возникающая в активных областях. Вращение С. с неоднородным распределением активных областей по диску обуславливает 27-дневную повторяемость формы кривой изменения со временем потока излучения С., наблюдаемого с Земли. Развитие или возникновение на видимом диске новых активных областей иногда нарушает строгую повторяемость формы этой кривой. Амплитуда изменений в радио- и мягком рентг. диапазонах составляет уже десятки процентов и увеличивается при удалении от оптич. диапазона в обе стороны. Со вспышками связаны всплески излучения с характерными временами от минут до часов. В радио- и рентг. диапазонах амплитуда этих всплесков может быть очень большой.

ИК-излучение — тепловое излучение верх. фотосферы. Поток дальнего ИК-излучения монотонно возрастает с уменьшением длины волны: на 100, 20 и 5 мкм он составляет соответственно 0,37, $2,3 \cdot 10^3$ и $5,5 \cdot 10^4$ Вт/(м²·ст-км). В указанном диапазоне яркостная темп-ра постепенно возрастает от 4400 до 5500 К. В све-

излучения. Непрерывное ИК-излучение не зависит от степени активности С.

Оптическое и УФ-излучение — непрерывное излучение, изрезанное фраунгоферовыми линиями. В диапазоне 800–180 нм содержится ок. $\frac{1}{2}$ всей энергии, излучаемой С. В УФ-диапазоне становится заметными вариации излучения, связанные с солнечной активностью. В солнечном спектре отодвинуто более 30000 линий поглощения. Энергия, поглощаемая в этих линиях, составляет 30% энергии непрерывного излучения в УФ-диапазоне, доходит до 40–50% в диапазоне 300–400 нм и постепенно уменьшается к красной области спектра. Наблюдается также ряд полос простейших молекул CN, CO и др. Эти линии возникают в области температурного минимума между фотосферой и хромосферой, а также над пятнами.

В диапазоне 30–180 нм солнечный спектр представляет собой набор эмиссионных линий. Эти линии излучаются в узком переходном слое между хромосферой и короной при темп-рах от 10^4 до 10^6 К. Часть излучения водорода в линиях лаймановской серии, а также линия нейтрального гелия, $\lambda = 58,4$ нм, возникает в хромосфере. Самыми яркими линиями (помимо лаймановских линий) являются линии наиб. обильных элементов (линия He I, $\lambda = 30,4$ нм, Si — IV, OII — VI, Si II — IV, железа и др.). В этом же диапазоне наблюдаются также неск. участков непрерывного излучения — рекомбинац. континуумов водорода, нейтрального и ионизов. гелия.

Излучение в этой области спектра изменяется на десятки процентов в зависимости от уровня солнечной активности, и хотя энергия этого излучения небольшая, её достаточно, чтобы ионизовать и нагреть верх. слой земной атмосферы.

Рентгеновое излучение. Источником рентг. излучения является солнечная корона, гл. обр. её плот-

ные ниж. слои (т. е. внутр. корона). Это излучение горячей разреженной оптической тонкой плазмы с темп-рой $\approx 2 \cdot 10^6$ К. Диапазон ренгг. излучения спокойной короны от 1 нм до неск. десятков нм. Поток ренгг. излучения на орбите Земли $1-3$ эрг/см²·с. или $5 \cdot 10^{-4}$ среднего солнечного потока в видимой области спектра. Ренгг. излучение состоит из 2-х компонентов — линейчатого и непрерывного. Многочисл. спектральные линии ионов высокой кратности (железа, кремния, кислорода и др.) обусловлены возбуждением ионизированным ударом и последующими спонтанными переходами (свободно-связанное излучение). Непрерывное излучение связано с наменениями энергии свободных электронов в электрич. поле ионов (свободно-свободное излучение). Вклад линейчатого излучения в суммарное излучение в неск. раз больше, чем непрерывного, однако на КВ-конце (ок. 1 нм) вклады обоих типов излучения становятся сравнимыми.

Активные области в короне — корональные конденсации излучают более интенсивно. Это вызывает флуктуации ренгг. излучения при возникновении и развитии активных областей на видимой стороне С., появления 27-дневной периодичности в регистрируемом потоке, связанной с вращением С. В зависимости от уровня солнечной активности суммарная мера эмиссии изменяется от $3 \cdot 10^{48}$ см⁻² до 10^{50} см⁻² при незначит. изменениях темп-ры. Изменения ренгг. излучения сильнее выражены в КВ-части диапазона. Нек-рые мощные центры активности вызывают появление заметных потоков излучения даже в диапазоне 0,3—1 нм, что связано с нагревом плазмы до темп-р, в неск. раз превышающих ее ср. значение в источниках внутр. короны.

Ренгг. излучение С. возрастает и далеко простирается в область высоких энергий при любых нестационарных процессах, особенно вспышках. По величине потока излучения вблизи орбиты Земли в диапазоне 0,1—0,8 нм вспышки делятся на 3 класса: А, М и Х (соответственно потоки $(1-9) \cdot 10^{-3}$, $(1-9) \cdot 10^{-2}$ и более 10^{-1} эрг/см²·с). Тепловое излучение вспышек, длящееся все время вспышки (от минут до часов), связано с образованием плазмы с $T \leq 3 \cdot 10^7$ К. В спектре наблюдаются линии ионов, у к-рых остались только 1—2 электрона (Fe XXV и др.). Кроме теплового излучения горячей плазмы при нек-рых вспышках генерируется нетепловое излучение электронов, ускоренных до энергий, превышающих 10 кэВ (иногда 100 кэВ и более). Как правило, эти вспышки продолжаются не более 100 с.

Подробнее изучена структура источников ренгг. излучения С. Излучающая плазма заключена в систему петель — арок, являющихся пучками силовых линий магн. поля, проникающего из фотосферы во внутр. корону. Физ. условия в петлях — темп-ра $\approx 2 \cdot 10^6$ К и концентрация электронов $n_e \approx 10^{18}$ см⁻³ — неизменно изменяются как в самой петле, так и при переходе от одной петли к другой. Длины петель составляют 10^8-10^{10} см. Газ вне петель (там, где силовые линии магн. поля уходят на большие расстояния от С.) из-за своей малой плотности и меньшей темп-ры слабее излучает в ренгг. диапазоне (корональные дыры).

Источник теплового ренгг. излучения при вспышках — система петель, заполненных плазмой с $T \approx 3 \cdot 10^7$ К и $n_e \leq 10^{14}$ см⁻³. Пучки нетепловых электронов выходят в начале нек-рых вспышек весьма плотными, до 10^{-4} тепловых электронов может ускоряться до энергий, превышающих 15 кэВ.

М. А. Лыткин.

Радиоизлучение. Плотность потока радиоизлучения С. на орбите Земли в спокойных условиях от 10^7 Ян в сантиметровых волнах до 10^8 Ян в метровом диапазоне. Она возрастает во время вспышек, связанных с крупными вспышками, до 10^9 и 10^{10} Ян соответственно.

Регистрация радиоизлучения С. на разных волнах позволяет получать информацию о параметрах, струк-

туре и динамич. явлениях в разл. слоях атмосферы С. Сантиметровые и дециметровые волны исходят из хромосферы, переходного слоя и ниж. короны (расстояние от фотосферы $r < 10-20$ тыс. км), излучение метрового и декаметрового диапазонов генерируется в короне ($r \sim 0,2-4 R_{\odot}$), а гектометровые и километровые волны — в самых внеш. слоях короны и в межпланетной среде (фиксируются при помощи спутников и космич. аппаратов).

Невозможный, наиб. низкий (фоковый) уровень радиоизлучения С. — т. е. осн. компонент, или излучение, «спокойного» С. (рис. 6). Это тепловое излучение, яркостная темп-ра T_b к-рой соответствует ионич. темп-ре той же сл. где оптич. толща $\tau_0 \sim 1$. При переходе от милли-

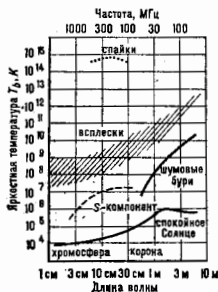


Рис. 6. Зависимость яркостной температуры основных компонентов радиоизлучения Солнца от длины волны (частоты).

метровых к метровым волнам T_b возрастает от $5 \cdot 10^4$ до 10^8 К.

При наличии активных областей на диске над фоковым уровнем выделяются также локальные источники повш. радиоизлучения, существующие в течение мн. дней. В сантиметровом и дециметровом диапазонах регистрируется медленно меняющийся компонент (S-компонента). Она включает в себя неск. составляющих.

Одна из них охватывает всю активную область (неск. минут дуги) и представляет собой слабо поляризованное тормозное излучение корональной конденсации, в к-рой темп-ра и плотность повышены в неск. раз. Непосредственно над пятнами на $\lambda \sim 2-4$ см доминируют компактные ($\sim 20''$) и яркие ($T_b \approx (1,5-2) \cdot 10^8$ К) источники поляризованного магнитотормозного радиоизлучения, исходящего из оптически толстых гирорезонансных слоев (т. е. слоев, для к-рых частота принимаемого радиоизлучения кратна ω_{ch}) $2 \omega_{ch}$ (обыкновенные волны) и $3\omega_{ch}$ (необыкновенные волны), где ω_{ch} — гиromагнитная частота электронов. Существование, что в источниках, связанных с пятнами, темп-ра достигает корональных значений уже на высотах $r \sim 1-2$ тыс. км, где магн. поле $H \sim 1000-1500$ Гс. Поляризация, атак к-рой соответствует необыкновенной волне, возникает в таких источниках вследствие того, что для опред. длины волны слой $3\omega_{ch}$ располагается в переходной области между хромосферой и короной на больших высотах, т. е. в области с большей темп-рой, чем уровень $2\omega_{ch}$.

Две др. составляющие S-компоненты имеют нетепловую природу и свидетельствуют о непрерывном ускорении электронов в активных областях. Это прежде всего меняющаяся составляющая — компактные ($\sim 10''$), яркие ($T_b \geq 5 \cdot 10^8$ К) радиостанции, к-рые особенно хорошо наблюдаются на $\lambda \sim 6$ см и располагаются над линией раздела поляризатора фотосферного магн. поля, в верх. части корональных петель. Другая нетепловая составляющая имеет вид протяженного ($1-2'$) гало и характеризуется максимумом плотности потока на $\lambda \sim 10-15$ см.

Явно нетепловую природу имеет также НЧ-аналог S-компоненты — шумовые бури. Они фиксируются над крупными развивающимися активными областями, характеризуются сильной поляризацией и состоят из усредненного непрерывного фона (континуума) с $T_b \sim$

$\sim 10^7 - 10^8$ К и многочисленные дискретных всплесков разных типов. На $\lambda \sim 1-5$ м чаще всего наблюдаются т. н. всплески I типа — кратковременные (0,1—2 с) и узкополосные (2—10 МГц) элементы излучения. Конкретная картина неуровняного ускорения электронов в активных областях и механизм генерации всплесков I типа ещё не до конца ясны. Предполагается, что ускорение частиц происходит в результате локального магн. пересоединения в скрученных магн. петлях, на фронтах слабых ударных волн или в токовом слое корональных лучей, наблюдаемых над активными областями. При интерпретации континуума и всплесков I типа рассматривают разл. варианты плазменного механизма (возбуждение ленгмюровских или верхнегибридных волн с последующей конверсией этих волн в эл.-магн. излучение за счёт рассеяния на ионах или НЧ-турбулентности), а также циклотронного механизма (непосредств. генерация обыкновенных волн на ниж. гармониках гирочастот; см. *Волны в плазме*).

В шумовых бурях на $\lambda \leq 5$ м, а также на гектометровых волнах преобладают всплески III типа (см. ниже). В дециметровом диапазоне во время бурь наблюдаются также двойные дрейфующие всплески («зах»-всплески), узкополосные всплески с расщеплением по частоте ($\Delta f \sim 100$ кГц), др. тонкоструктурные элементы.

Наиб. интенсивные и разнообразные радиовсплески связаны с солнечными вспышками (рис. 7). В случае

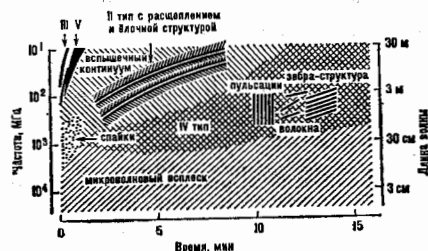


Рис. 7. Схема динамического спектра радиовсплесков, связанных с крупной вспышкой.

сравнительно слабых вспышек в сантиметровом диапазоне регистрируются всплески длительностью минуты — десятки минут, к-рые являются результатом нагрева плазмы в ниж. короне до $T \sim (1-5) \cdot 10^6$ К. В метровом диапазоне и на более длинных волнах такие события сопровождаются всплесками III типа. Это наиб. часто встречающийся вид активности в радиодиапазоне. Гл. свойства всплесков III типа — быстрый дрейф излучения от ВЧ к НЧ и гармонич. структура (однорем. излучение на частотах, относящихся как 2:1). Всплески III типа возникают вследствие возбуждения ленгмюровских волн потоками электронов, распространяющихся через корону и межпланетную среду со скоростью $\sim 10^8$ км/с (энергия электронов — десятки кэВ). (Дрейф по частоте обусловлен уменьшением плазменной частоты при движении электронов на более плотных областях в менее плотные.) Такая модель подтверждена прямыми измерениями на космич. аппаратах электронных потоков и генерирующей ими ленгмюровской турбулентности (см. *Турбулентность плазмы*). При этом излучение осн. тона появляется в результате рассеяния ленгмюровских волн на тепловых ионах или на НЧ-турбулентности, а излучение гармоника — вследствие комбинац. взаимодействия встречных ленгмюровских волн. Несмотря на эффект квазилинейной релаксации, поток электронов сохраняет способность генерировать всплески III типа на

всей трассе распространения от С. до Земли (см. *Взаимодействие частиц с ионами*). В сек-рых моделях это объясняется стабилизацией *пушковой неустойчивости* за счёт индуциров. рассеяния ленгмюровских волн на тепловых ионах или за счёт др. нелинейных эффектов, выводящих ленгмюровские волны из резонанса с потоком.

При распространении электронных потоков вдоль замкнутых магн. петель генерируются разновидности всплесков III типа со сменной направлением частотного дрейфа (U- и J-всплески), а при захвате электронов в замкнутых магн. петлях вслед за всплесками III типа на $\lambda \sim 3-10$ м появляется континуальное излучение — всплески V типа — длительностью от десятков секунд до минут. Этот тип радиоизлучения также интерпретируется в рамках плазменного механизма.

В отд. вспышках средней и большой мощности после всплесков III, V типов на $\lambda < 1,5-2$ м наблюдаются всплески II типа. Они тоже обнаруживают гармонич. структуру и дрейф сравнительно узких ($\Delta f/f \sim 0,1$) полос излучения от ВЧ к НЧ. Однако скорость дрейфа примерно в 100 раз ниже, чем у всплесков III типа. Это связано с тем, что агентом, инициирующим всплески II типа, являются *бесстационарные ударные волны*, распространяющиеся от вспышек со скоростью $\sim 10^4$ км/с. В разл. моделях рассматриваются квазиперпендикулярные или квазипараллельные ударные волны с магн. числом Маха $M < 2$ или $2 \leq M < 10$. Механизм генерации всплесков II типа по существу такой же, как и у всплесков III типа (т. е. плазменный), за исключением одной дополнит. стадии — ускорения частиц на фронте ударной волны. Об ускорении электронов свидетельствует т. в. влоачная структура — последовательность быстро дрейфующих элементов (миллисекундных всплесков III типа), выходящих из осн. полос излучения в сторону НЧ и ВЧ. Наблюдаемое во всплесках II типа частотное расщепление каждой из гармоник на две одинаковые полосы можно интерпретировать как плазменное излучение перед фронтом и за фронтом ударной волны или как следствие осцилляторной структуры фронта ударной волны.

В импульсных вспышках ударная волна, возбуждающая всплеск II типа, носит взрывной характер. В мощных длит. вспышках ударная волна, напротив, является поршневой (роль поршня играет корональный транзит), а сам всплеск II типа имеет продолжение на гектометровых и километровых волнах, т. е. при распространении ударной волны в межпланетном пространстве.

Большие вспышки сопровождаются также интенсивными микроволновыми всплесками со сложными временн. профилем и пространственной структурой. Здесь на фоне сравнительно плавных вариаций за время порядка минут на нач. фазе вспышки регистрируются многочисл. узкополосные ($\Delta f \sim 10-15$ МГц) и интенсивные выбросы излучения миллисекундного масштаба. Такие же выбросы, или спайки, наблюдаются в дециметровом диапазоне. Источник микроволновых всплесков — низкие корональные магн. петли, содержащие электроны с энергией десятки и сотни кэВ. Фоновое излучение с $T_b \sim 10^8 - 10^{11}$ К связывается с гиротронным (пиклотронным) излучением в магн. поле $H \sim 100-500$ Гс или с плазменным излучением в плотных ($N \sim 10^{11} - 10^{13}$ см $^{-3}$) всплесковых ядрах. Миллисекундные спайки характеризуются наиб. высокой яркостью темп-рой (до 10^{15} К). Предполагается, что они представляют собой проявление отд. элементарных актов всплескового энерговыделения, отражают его фрагментарный характер и генерируются в результате маэрового циклотронного излучения (см. *Маэер на циклотронном резонансе*) на низких гармониках электронной гирочастоты.

В течение взрывной фазы крупных вспышек (практически одновременно с микроволновыми всплесками и всплесками III типа) во всём диапазоне от децимет-

ровых до дециметровых волн начинается излучение всплывшего континуума, переходящее затем в широкополосный длительный и многокомпонентный всплеск IV типа. Такое континуальное излучение — следствие заполнения энергичными электронами магн. структур, находящихся на разных высотах над активной областью. При этом в *магнитных аэоухах* формируются неравномерное распределение электронов, развиваются конусные неустойчивости и реализуется плазменный механизм излучения. Часть энергичных электронов оказывается захваченной внутри областей плазмы или петлеобразных корональных транзитов, наблюдаемых в видимом диапазоне. В частности, изолированные движущиеся источники всплесков типа IVM удалась отодвинуть с наиб. яркими и плотными образованиями вблизи вершины транзита, где электронная плотность повышена по сравнению с фоновой в 20—70 раз. Это даёт возможность интерпретировать метровые IVM-всплески на расстояниях от фотосферы $r \sim 1-1,5 R_{\odot}$ также в рамках плазменного механизма. При удалении источников IVM-всплесков на большие расстояния преобладающим становится гирисинхротронное излучение субрелятивистских электронов в областях плазмы с совств. магн. полем $H \sim 1-3$ Гс.

Всплески IV типа, особенно на дециметровых волнах, обладают богатой тонкой структурой. Здесь наблюдаются широкополосные пульсации с характерным временем ~ 1 с, всплески в поглощении, дрейфующие волокна, зebra-структура и т. д. Появление такого своеобразного радиоизлучения отражает структуру излучения самой корональной плазмы, а также указывает на сложный характер взаимодействия между разл. типами волн и частиц, к-рые происходит в короне на разл. стадиях всплеска.

Радиоизлучение С. широко используется в качестве индекса солнечной активности (напр., поток на $\lambda = 10,7$ см), а также для диагностики всплесков и краткосрочного прогнозирования тех эффектов, к-рые они вызывают на Земле (радица, условия в ближнем космосе, геомагн. бури, ионосферные возмущения и т. д.).

Лит.: Железяков В. В., Радиоизлучение Солнца и планет, М., 1964; его же, Электронные волны в космической плазме, М., 1977; Киллал С. А., Пилсбери Р. С. В., Цитогович В. Н., Физика плазмы солнечной атмосферы, М., 1977; Крюгер А., Солнечная радиострономия и радиофизика. Введение, пер. с англ., М., 1984.

И. М. Чертов.

Гамма-излучение Солнца регистрируется совр. приборами только во время всплесков (уровень γ -излучения спокойного С. слишком низок). Зарегистрировано 140 солнечных всплесков, сопровождающихся эмиссией измеримых потоков γ -квантов с энергией более 300 кэВ. Для 100 всплесков измерен энергетич. спектр γ -излучения и в 50 случаях обнаружены ядерные γ -линии. По длительности фронта (нарастания) и спада импульсов γ -излучения всплески удаётся разделить на импульсные (общая длительность не более 1 мкс при длительности фронта и спада отд. импульсов неск. секунд) и постельные (до 10—20 мин и неск. десятков секунд соответственно).

В результате взаимодействия ускоренных во всплесках протонов, α -частиц и более тяжёлых ядер с веществом солнечной атмосферы происходит возбуждение ядерных уровней, расщепление ядер, генерация новых элементов и изотопов (нуклидов). Возбуждённые ядра быстро излучают избыток энергии и переходят в осн. состояние. При этом каждый изотоп излучает свой характерный γ -квант (см. *Гамма-излучение*). Наиб. важные с астрофиз. точки зрения линии: 6,13 МэВ (^{40}O); 4,44 МэВ (^{12}C); 2,31 МэВ (^{24}Mg); 1,78 МэВ (^{28}Si); 1,63 МэВ (^{20}Ne); 1,37 МэВ (^{24}Mg); 1,24 МэВ и 0,85 МэВ (^{4}He). Эти линии образуются путём прямого возбуждения указанных ядер. Кроме того, имеются оцильные линии 0,48 МэВ (^7Li) и 0,43 МэВ (^7Be), к-рые образуются в реакциях синтеза $^4\text{He} (\alpha, p) ^7\text{Li}$ и $^4\text{He} (\alpha, n) ^7\text{Be}$. Вре-

мена жизни возбуждённых уровней пренебрежимо малы ($\leq 10^{-9}$) по сравнению с временами ускорения и торможения частиц и ядер. Поэтому приведённые γ -линии, называемые мгновенными, служат прекрасными хронометрами процессов ускорения и взаимодействия частиц.

Кроме мгновенных γ -линий в солнечной атмосфере генерируются т. н. задержанные γ -линии 2,22 МэВ и 0,51 МэВ. Задержка обусловлена конечным временем захвата нейтронов (см. *Радиационный газет*) водородом (линия 2,22 МэВ) и аннигиляцией позитронов (линия 0,51 МэВ). Нейтроны образуются в осн. в ядерных реакциях $^4\text{He} (p, n) ^3\text{He}$ и $^4\text{He} (p, 2p) ^3\text{He}$. Эти нейтроны сначала тормозятся в солнечном веществе до тепловых скоростей, а затем поглощаются протоном с генерацией γ -линии 2,22 МэВ либо ядром гелия-3 ($^3\text{He} (n, p) ^3\text{He}$) без генерации γ -квантов. Время торможения порядка неск. минут, и, как следует из теории, захват нейтронов имеет место в достаточно плотной среде (концентрация атомов более 10^{14} см $^{-3}$). Интенсивность γ -линии 2,22 МэВ даёт уникальную информацию о концентрации гелия-3 в фотосфере. Источником другой задержанной линии — аннигиляц. линии 0,51 МэВ являются позитронно-активные ядра ^{12}C , ^{12}N , ^{13}N , ^{14}O , ^{18}O , ^{19}Ne , к-рые генерируются в ядерных реакциях в солнечной атмосфере во время всплеска. Позитроны генерируются также путём распада β^+ -мезонов, образующихся в ядерных реакциях с участием высокоэнергичных протонов. Прежде чем произойдёт аннигиляция позитронов, они замедляются за счёт ионизац. и радиац. потерь от нач. энергий (сотни кэВ — десятки МэВ) до тепловых. Время задержки линии 0,51 МэВ определяется периодом полураспада радиоактивных ядер и временем замедления позитронов. Последнее зависит от плотности и величины магн. поля в области, где аннигилируют позитроны. Аннигиляция может быть свободной с генерацией двух γ -квантов с энергией каждого 0,51 МэВ или протекать через состояние квазиатома *позитрония*. Вероятность образования позитрония в состоянии со спином 0 составляет 25%, со спином 1—75%. В первом случае позитроний аннигилирует на два γ -кванта с энергией 0,51 МэВ каждый, во втором случае — на три γ -кванта, к-рые формируют непрерывный спектр в области энергии ниже 0,5 МэВ. Относит. вероятность двухфотонной и трёхфотонной аннигиляции определяется плотностью вещества в области генерации излучения. Ширина аннигиляц. линии определяется темп-рой этой области. Т. о., размер временной ход и энергетич. спектр аннигиляц. квантов, можно определить характеристики частиц замедления и аннигиляции позитронов.

γ -Спектроскопия солнечных всплесков позволяет определить изотопный и элементный состав не только той области солнечной атмосферы, где протекают ядерные реакции, но и состав потоков ускоренных частиц. Ширина ядерной γ -линии определяется кинематической реакцией, в к-рой данная линия генерируется. При возбуждении ядер солнечной атмосферы протонами и α -частицами линия уширяется от 1 до 2%. Однако когда линия генерируется при взаимодействии ускоренного ядра с водородом и гелием солнечной атмосферы, уширение достигает 25%. На рис. 8 приведён расчётный энергетич. спектр мгновенных γ -линий. В верх. части рисунка дан полный спектр (а), в нижней — только уширенный спектр γ -излучения ускоренных ядер (б). Полный спектр содержит разл. узкие линии, наиб. интенсивными из к-рых являются линии ^{14}O , ^{12}C , ^{20}Ne , ^{24}Mg , ^{28}Si и ^7Be . В уширенном спектре выделяется только две особенности между 4 и 5 МэВ (в осн. от ^{12}C и между 1 и 2 МэВ (от ^{20}Ne , ^{24}Mg , ^{28}Si и ^7Be). Вклад уширенного компонента в общий спектр невелик. Однако во всплесках с обогащением ускоренных частиц тяжёлыми элементами вклад уширенного компонента оказывается существенным. На рис. 9 приведён пример измеренного в космос. эксперименте спек-

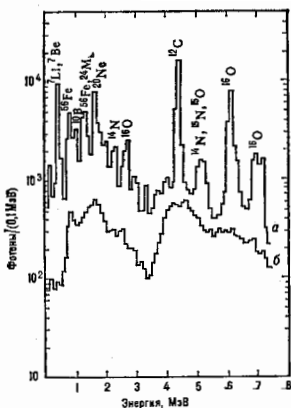


Рис. 8. Расчётный спектр мгновенных у-линий: а — полный, б — усуренный. Ширина энергетического окна принята равной 100 МэВ, что соответствует экспериментальному значению для аппаратуры, используемой в космических экспериментах. По вертикальной оси — число фотонов в интервале энергий 0,1 МэВ.

тра γ -излучения от вспышки 27 апр. 1981, а также расчётный спектр. При этом предполагалось, что состав ускоренных ядер и вещества в области генерации у-линий такой же, как и в фотосфере. Видно, что в измеренном спектре чётко выделяются предсказанные теорией наиб. интенсивные линии. В то же время в наблюдаемом спектре имеется обогащение линиями тяжёлых элементов ^{20}Ne , ^{24}Mg , ^{28}Si и ^{56}Fe (область 0,8—2 МэВ) по сравнению с линиями CNO (4—8 МэВ). Отсюда следует, что состав ускоренных ядер в области генерации у-линий отличается от фотосферного, и, т. о., существует значит. отличие состава в разл. областях солнечной атмосферы.

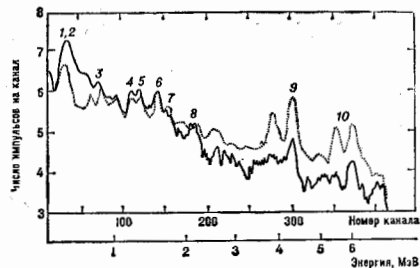


Рис. 9. Экспериментальный и расчётный (пунтир) спектры для вспышки 27 апреля 1981: 1) 0,43 (^7Be); 2) 0,28 (^6Li); 3) 0,85 (^{10}B); 4) 1,24 (^{12}C); 5) 1,37 (^{24}Mg); 6) 1,83 (^{28}Si); 7) 1,78 (^{56}Fe); 8) 2,31 (^{20}Ne); 9) 4,4 (^{12}C); 10) 6,13 (^{16}O). Энергия линий даны в МэВ.

Совместный анализ эксперим. данных по солнечному рентг. и γ -излучению, а также по потокам частиц в межпланетном пространстве позволяет сделать следующие выводы. В импульсных вспышках наиб. вероятный источник ускоренных частиц — плотная область с большим магн. полем B ($10^{11} \text{ см}^{-2} \leq B \leq 10^{13} \text{ см}^{-2}$,

$B \geq 300 \text{ Гс}$, N — концентрация частиц). Нерелятивистские и релятивистские электроны, протоны и ядра ускоряются в импульсной фазе солнечной вспышки. Ускорение электронов (до релятивистских энергий), протонов и ядер (по крайней мере, до неск. десятков МэВ) происходит одновременно и быстро (в пределах времени разрешения эксперим. аппаратуры, $\sim 1 \text{ с}$). Пока нет обоснованной модели одновременного и столь быстрого ускорения электронов и протонов. Не исключена возможность ещё более быстрого ($< 1 \text{ с}$) ускорения протонов до десятков и сотен МэВ. Солнечные вспышки, от к-рых удалось зарегистрировать высокоэнергетичные нейтроны (вплоть до 10^8 МэВ) и γ -кванты (до 150 МэВ), имеют тенденцию локализовываться у лимба. Это явление (лимбовое урчнение) легко объяснить на примере нейтронов. Согласно теории, высокоэнергетичные нейтроны движутся в осн. в направлении движения генерирующих их протонов. Поэтому нейтроны, зарегистрированные вблизи Земли, должны быть образованы теми протонами, к-рые в атмосфере С. двинулись в сторону Земли. Для вспышек вблизи лимба путь и толща вещества, проходящие в атмосфере С. протонами (движущимися в направлении Земли), наибольшие. Следовательно, кол-во нейтронов (пропорциональное толще вещества, пройденной протонами), зарегистрированное вблизи Земли для лимбовых вспышек, будет больше, чем для вспышек на диске С. Т. о., при данной чувствительности аппаратуры вероятность регистрации нейтронов будет тем больше, чем ближе область вспышки к лимбу.

Лит.: Кочаров Т. Е., Новые данные о генерации ядерных частиц в импульсной фазе солнечных вспышек. АУФН, 1982, т. 137, с. 532; в то же ж. Солнечные «кванты и нейтроны». Изв. АН СССР, Сер. физ., 1983, т. 47, № 9, с. 1716; Кочаров Т. Е., Кочаров Г. А., Кочаров Г. А., Generation of high energy neutral radiation in flare loops, «Solar Phys.», 1980, v. 125, p. 67.

Г. Е. Кочаров.

СООБЩЕНИЕ — совокупность знаков (символов), несущая информацию. Процесс создания С. может быть рассмотрен на примере следующей модели (рис.).



называемое кодером объекта, позволяет поставить в соответствие данному состоянию $k \in C$ m из множества S, M , т. е. происходит отображение $K \rightarrow M$. Совокупность объекта и его кодера наз. источником С. Отдельное $S, m \in M$ представляет собой слово, записанное в век-ром алфавите. Если длина слова конечна и ограничено число букв в алфавите, то множество S в рамках подобной модели дискретно и конечно, что соответствует реальным системам сбора и обработки информации. Если состояние объекта характеризуется непрерывными значениями величины n , т. о., множество K — интервал, а множество M — дискретно и конечно, кодирование осуществляется специфич. процедурой аналого-цифрового преобразования (см. также Сигнал, Кодирование информации, Теория информации).

А. Н. Ефимов.

СООТВЕТСТВЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ — состояния вещества, имеющие одинаковые приведенные значения термодинамич. величин (тем-ры, давления, объёма и т. п.). Напр., при описании критической точки жид-

кость — пар вводят приведенные темп-ру $T' = T/T_c$, давление $P' = P/P_c$ и объём $V' = V/V_c$, где T_c , P_c , V_c — значения соответствующих величин в критич. точке. *Уравнения состояния* разл. веществ, записанные через приведенные термодинамич. величины, совпадают. Это утверждение наз. з а к о н о м С. С. Напр., используемое при описании фазового перехода жидкость — пар ур-ние Ван-дер-Ваальса в приведенных переменных приобретает универсальный вид, не содержащий характеристик конкретного вещества:

$$(P' + 3/V'^2)(3V' - 1) = 8T'.$$

Т. о., равенство приведенных значений двух величин (напр., темп-ры и объёма) для двух веществ приводит к равенству для них и третьей величины (давления). Закон С. с. является общим утверждением, не связанным с конкретным видом ур-ния состояния.

Обобщение понятия С. с. обусловлено изоморфностью критич. явлений в разл. физ. системах (см. табл. в ст. *Критические явления*). Флукуац. теория *фазовых переходов* 2-го рода в таких системах, основанная на представлении о *масштабной инвариантности*, позволяет сформулировать закон С. с. в иной форме: всякая безразмерная (по отношению к масштабным преобразованиям) комбинация термодинамич. величин, характеризующих фазовый переход, зависит от одного безразмерного параметра $x = \hbar^2 t^{-d}$, где $t = T/T_c - 1$, \hbar — обобщённое поле, сопряжённое параметру порядка, γ , β — критические показатели восприимчивости и параметра порядка (см. также *Приведённое уравнение состояния*).

Лит.: В а н д а у Л. Д., Д и ф ф и н Е. М., *Статистическая физика*, ч. 1, 3 изд., М., 1976; С т е п л я Г. Ф., *Фазовые переходы и критические явления*, пер. с англ., М., 1973; П а в л о в с к и й А. З., П о к р о в с к и й В. Л., Флукуационная теория фазовых переходов, 2 изд., М., 1982; М. В. Фейнман.

СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИП — постулат квантовой механики, требующий совпадения её физ. следствий в предельном случае больших квантовых чисел с результатами классич. теории. Квантовые эффекты существуют лишь при рассмотрении микрообъектов, когда величины размерности действия сравнимы с постоянной Планка \hbar . Если квантовые числа, характеризующие состояние физ. системы (напр., орбитальное квантовое число l), велики, то система с высокой точностью подчиняется классич. законам. С формальной точки зрения, С. п. означает, что в пределе $\hbar \rightarrow 0$ квантовомеханич. описание физ. объектов должно быть эквивалентно классическому.

Часто под С. п. понимают следующее более общее положение. Любая новая теория, претендующая на более глубокое описание физ. реальности и на более широкую область применимости, чем старая, должна включать последнюю как предельный случай. Напр., релятивистская механика (см. *Относительность теории*) в пределе малых скоростей ($v \ll c$) переходит в классическую. Формально переход осуществляется при $c \rightarrow \infty$.

Когда осн. положения теории уже сформулированы, С. п. представляет в осн. иллюстративный интерес и подчёркивает преемственность теоретич. построений. В ряде случаев С. п. помогает развить приближённые методы решения задач. Так, если в данной конкретной физ. проблеме \hbar можно считать малой величиной, то это равносильно т. н. *квазиклассическому приближению* квантовой механики. При этом нерелятивистское волновое *Шрёдингера уравнение* в пределе $\hbar \rightarrow 0$ приводит к классич. ур-нию Гамильтона — Якоби. Однако в первом возникновении новой теоретич. дисциплины, когда её принципы во многом ещё неясны, С. п. имеют самостоятел. значение.

С. п. был выдвинут Н. Бором (N. Bohr) в нач. 1920-х гг. в связи с проблемой спектров испускания и поглощения атомов. В созданной позже последовательной *квантовой механике* особенности атомных

спектров были объяснены на более глубокой основе, однако существ. черты её матем. аппарата определялись С. п. Напр., на С. п. следует, что коммутир. соотношения для разл. величин квантовой теории даются классическими *Пуассона скобками*, что *гамильтонов* физ. системы выражается через обобщённые координаты и импульсы так же, как и в классич. механике, и т. п. Значение С. п. далеко выходит за рамки квантовой механики. Им широко пользуются в квантовой теории поля, теории элементарных частиц, и без сомнения, он войдёт составной частью в любую новую квантовую теорию.

Лит.: В о р Н., Три статьи о спектрах и строении атомов, пер. с нем., М. — И., 1923. См. также лит. при ст. *Квантовая механика*. О. И. Зельдов.

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ — см. *Неопределённости соотношения*.

СОПЛО — канал (труба) переменного по длине поперечного сечения, предназначенный для разгона жидкостей или газов до заданной скорости и придания потоку заданного направления. Служит также устройством для получения газовых и жидкостных струй. Поперечное сечение С. может быть прямоугольным (плоские С.), круглым (осесимметричные С.), иметь форму кольца [кольцевые С., С. с центр. телом] или произвольную форму, в т. ч. форму эллипса или многоугольника (пространственные С.).

С. широко используются в технике: в паровых, водяных и газовых турбинах, в ракетных и воздушнореактивных двигателях, в *газодинамических лазерах*, в магнитогидродинамич. установках, в *аэродинамических трубах* и на газодинамич. стендах, при создании молекулярных пучков, в хим. технологии, в струйных аппаратах, в процессах дутья и др.

В С. происходит непрерывное увеличение скорости в жидкости или газа в направлении течения — от начального (обычно малого) значения v_0 во входном сечении С. до наиб. скорости v_2 на выходе С. При движении в С. внутрь, энергия рабочего тела преобразуется в кинетич. энергию вытекающей струи, сила реакции к-рой, направленная противоположно скорости истечения, наз. тягой. В силу закона сохранения энергии одновременно с ростом скорости в С. происходит непрерывное падение давления и темп-ры от их нач. значений p_0 , T_0 во входном сечении С. до наим. значений p_2 , T_2 в выходном. Т. о., для реализации течения в С. необходим нек-рый перепад давления, т. е. выполнение условия $p_0 > p_2$.

Если считать движение жидкости или газа по С. изотропным (см. *Изотропный процесс*) и стационарным и рассматривать средние по поперечному сечению S значения давления p , скорости v , плотности ρ и скорости звука c (одномерное приближение), то из Эйлера уравн.

$$v dv/dx = -\rho^{-1} dp/dx \quad (1)$$

(x — координата вдоль сопла), *неразрывности уравнения* $\rho v S = \text{const}$ и выражения скорости звука $c^2 = dp/d\rho$ получаем ур-ние

$$(v^2 - c^2) dv/dv = c^2 dS/S. \quad (2)$$

Из него видно, что при $v < c$ (дозвуковое течение по С.) знак dv противоположен знаку dS , т. е. для того, чтобы скорость течения по С. росла ($dv > 0$), площадь сечения с ростом x должна уменьшаться ($dS < 0$), а при $v > c$ (сверхзвуковое течение по С.) знаки dv и dS одинаковы, т. е. для получения роста скорости ($dv > 0$) необходимо увеличивать и площадь S вдоль С. ($dS > 0$). Физически это связано с тем, что при сверхзвуковой скорости течения газы из-за влияния сжимаемости плотности газа падают быстрее, чем растёт скорость вдоль С., и в силу ур-ния неразрывности для компенсации быстрого падения плотности необходимо увеличивать площадь S . Если $v = c$, то $dS = 0$ и ф-ция $S(x)$ прини-

мает экстремальное (минимальное) значение. Т. о., дозвукового С. имеет сужающуюся форму (рис. 1).

Наиб. скорость, к-рую можно получить в сужающемся С., равна скорости звука и достигается в его выходном (наиб. узком) сечении. Сверхзвуковое С., называемое также соплом Лаваля по имени его изобретателя — швед. инженера К. Г. П. де Лавалья (K. G. P. de Laval), имеет сначала сужающуюся, а затем расширяющуюся форму (рис. 2). Давление p_c в выходном

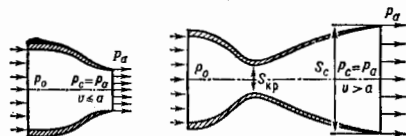


Рис. 1. Схема дозвукового сопла.

Рис. 2. Схема сверхзвукового сопла.

сечения дозвукового С. всегда равно давлению p_a в окружающей среде, куда происходит истечение из С. ($p_c = p_a$). При возрастании p_0 и неизменном p_a скорость v_c в выходном сечении дозвукового С. сначала увеличивается, а после того как p_0 достигнет некой определенной величины, v_c становится постоянной и при дальнейшем увеличении p_0 не изменяется. Такое явление наз. кризисом течения в С. После наступления кризиса ср. скорость истечения из дозвукового С. равна местной скорости звука ($v = c$) и наз. критической скоростью. В этом случае все параметры газа в выходном сечении С. также наз. критическими, а С. наз. звуковым.

В сверхзвуковом С. критическим наз. его наиб. узкое сечение. Кривая линия, на к-рой реализуется переход от дозвуковой к сверхзвуковой скорости течения (линия $v = c$), расположена в области мин. сечения С., поэтому ср. скорость в критич. сечении всегда близка к скорости звука. Относит. скорость $v_c/c = M_c$ и давление p_c/p_0 в выходном сечении сверхзвукового С. зависят только от отношения площади выходного сечения S_c к площади критич. сечения и не зависят в широких пределах от изменения относит. давления p_0/p_a . Давление в выходном сечении сверхзвукового С. может быть равно давлению в окружающей среде ($p_c = p_a$); такой режим течения в С. наз. расчётным, в противном случае — нерасчётным. Нерасчётные режимы характеризуются образованием волн разрежения вне С. в случае $p_c > p_a$ или ударных волн вне или внутри С. в случае $p_c < p_a$. Когда поток проходит через систему волн разрежения или ударных волн, давление становится равным p_a .

В более общем случае течения неадиабатического и неадиабатич. течения в С. у-ние типа (2) включает члены, учитывающие трение, подвод или отвод теплоты, массы и механич. работы к рабочему телу. С учётом этих воздействий переход скорости течения через скорость звука может происходить не только в геометрическом — сначала сужающемся, а затем расширяющемся С., но и при изменении знака воздействия на поток в канале пост. сечения. Так, дозвуковой поток в таком канале ускоряется при подводе теплоты (тепловое С.), массы (расходное С.), совершении газом мех. работы (механическое С.), а сверхзвуковой — при изменении знака этих воздействий на обратный. Под влиянием одностороннего воздействия величину скорости газового потока можно довести только до критической (до скорости звука), но нельзя перевести через неё.

Изменение скорости вдоль геом. С. определяется законом изменения площади $S(x)$ по длине С. Контур С., т. е. вид ф-ции $S(x)$ в одностороннем приближении,

определить нельзя. Поэтому развита теория двумерных (плоских и осесимметричных) и трёхмерных (пространственных) течений в С., основанная на решении (гл. обр. численными методами с использованием ЭВМ) осн. дифференц. у-рий газовой динамики с соответствующими граничными и нач. условиями. В теории С. решаются две задачи: прямая — определение течения в С., контур к-рого задан, обратная — определение контура С., обладающего к. л. заданными свойствами. Напр., в аэродинамич. трубе С. должно обеспечить создание на выходе, т. е. в рабочей части аэродинамич. трубы, однородного (по величине и направлению) потока с заданной скоростью (или Маха числом $M_c = v/c$), а контур С. ракетных и воздушно-реактивных двигателей определяется так, чтобы получить макс. импульс потока на выходе С. (макс. тягу) при заданных ограничениях массы и габаритов С. Чтобы удовлетворить поставленным требованиям в широком диапазоне изменения условий течения (напр., изменения числа Маха С. аэродинамич. труб, скорости и высоты полёта летат. аппарата с ракетным или воздушно-реактивным двигателем), применяют регулируемые С. В сверхзвуковых С. аэродинамич. труб и дозвуковых С. двигателей применяют механч. регулирование площади критич. сечения С. $S_{кр}$, что позволяет путём изменения отношения $S_{кр}/S_c$ изменять число Маха и давление на выходе С., а в сверхзвуковых С. двигателей с той же целью кроме регулирования $S_{кр}$ используют выдвижные (телескопические), раскрываемые и разворачивающиеся насадки, дискретным образом изменяющие S_c .

Теория С. рассматривает течение реального рабочего тела в С. и учитывает трение, теплообмен рабочего тела со стенками С., наличие в газовом потоке жидких и твёрдых частиц (см. *Двуфазное течение*), неравновесные хим. реакции и физ. процессов возбуждения внутр. степеней свободы молекул, переноса лучистой энергии, воздействия эл.-магн. полей и др. Все эти процессы, связанные с отличием рабочего тела от идеального газа, приводят к возникновению ряда видов потерь в С., уменьшающих тягу двигателей или вид турбин. Развитие теории С. дало ответ на многие принципиальные вопросы изучения движения жидкостей и газов. Наряду с теорией С. разработаны сложные эксперим. методы исследования течения в С., требовавшие создания спец. гидродинамич. установок и газодинамич. стендов, а также системы измерения сил и параметров течения.

Лит.: Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика, 3 изд., ч. 1—2, М., 1981; Стерн и Л. Е., Основы газовой динамики двухфазных течений в соплах, М., 1974; Пирумов В. У. Г., Росликов Г. С., Течения газа в соплах, М., 1978. С. Л. Вишневецкий.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ — активное сопротивление антенны или любого др. излучателя, потеря мощности в к-ром эквивалентна её утрате волнами в окружающее пространство, т. е. излучению. Обычно С. и вводит как составляющую входного сопротивления антенны $Z_{вх}$ при подключении последней к линии передачи с волновым сопротивлением Z_0 . Для простейшей эквивалентной схемы последовательно соединённых сопротивлений $Z_{вх} = R_x + R_{п} + iX_x$, где $R_x = C. и., R_{п}$ — сопротивление омических потерь, X_x — реактивное сопротивление, обусловленное полями в реактивных элементах антенны (ёмкостях и индуктивностях), а также в полях сточных волн, сосредоточенных в её окрестности (иногда эту часть реактивного сопротивления называют реактисмом излучения). Идеальное согласование идеального излучателя ($R_{п} = 0$) с идеальной линией ($Im Z_0 = 0$) достигается при выполнении условий $X_x = 0, R_x = R_0$. М. А. Миллер.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАГНИТНОЕ — см. *Магнитное сопротивление*.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ — см. *Электрическое сопротивление*.

СОПРЯЖЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в голограмме и — изображения, сформированные волнами с комплексно-сопряженными амплитудами. Одновременно два С. и. возникают при восстановлении двумерных голограмм. Явление обусловлено неоднозначностью восстановления объектного волнового поля по записи картины интерференции между объектами и опорным излучением на двумерном носителе (см. *Голография*).

Распределение интенсивности в интерференц. картине, регистрируемой на голограмме, может быть записано следующим образом:

$$I(x, y) = |A_1(x, y)|^2 + |A_2(x, y)|^2 + A_1^*(x, y)A_2(x, y) + A_2(x, y)A_1^*(x, y), \quad (1)$$

где $A_1(x, y)$ — амплитуда волны, распространяющейся от объекта; $A_2(x, y)$ — амплитуда опорной волны. Значок* обозначает комплексное сопряжение. Если после фотохим. обработки фотоматериала коэф. амплитудного пропускания голограммы пропорционален экспозиции, то при освещении голограммы волной с амплитудой A_2 поле за голограммой может быть записано следующим образом:

$$A(x, y) = K[|A_2(x, y)| |A_1(x, y)|^2 + A_2(x, y) |A_1(x, y)|^2 + |A_2(x, y)|^2 A_1(x, y) + A_2(x, y) A_1^*(x, y)]. \quad (2)$$

Здесь K — коэф. пропорциональности. Пусть при записи и восстановлении изображения используется плоская опорная волна, тогда $|A_2(x, y)|^2$ — пост. величина и третье слагаемое в (2) описывает компоненту поля, амплитуда к-рой пропорциональна амплитуде волны $A_1(x, y)$, распространяющейся от объекта при записи голограммы. Эта компонента формирует мнимое изображение объекта. Последнее слагаемое в (2) пропорционально комплексно-сопряженной амплитуде исходной объектной волны, формирующей сопряженное действит. изображение. При записи голограмм по схеме Габора оба С. и. и фон, определяемые первыми двумя слагаемыми в (2), находятся на одной оси, что затрудняет наблюдение восстановленных изображений. Этот недостаток отсутствует у голограмм, зарегистрированных по схеме Лейта, где С. и. и фон разнесены в пространстве таким образом, что могут наблюдаться раздельно.

При записи картины интерференции между объектным и референтным излучением в объеме регистрирующей среды формируются трехмерные голограммы. Эти голограммы при соответствующем выборе толщины слоя восстанавливают одно изображение. Для восстановления таких голограммами С. и. используют восстанавливающую волну, сопряженную опорной. В случае плоской опорной волны требование сопряженности обеспечивается антипараллельностью распространения восстанавливающей волны. В случае расходящейся опорной волны в качестве восстанавливающей служит волна, сходящаяся к источнику опорной волны. Наряду с методами формирования сопряженных волн и изображений с помощью стационарных голограмм существуют методы, основанные на использовании динамич. голограмм.

Лит.: Гудмен Дж., Введение в Фурье-оптику, пер. с англ., М., 1970; Кольер Р., Беркхарт К., Лин Л., Оптическая голография, пер. с англ., 1973; Оптическая голография, под ред. Г. Коффинда, пер. с англ., т. 1—2, М., 1982.

А. Д. Гальперин

СОПРЯЖЕННЫЕ ТОЧКИ в оптике — две точки, к-рые по отношению к оптч. системе являются одна — объектом, вторая — его изображением; при этом вследствие обратности световых лучей объект и изображение могут взаимно меняться местами. Понятие С. т. вполне строго применимо только к идеальным безаберрац. оптч. системам (см. *Геометрическая*

оптика), для к-рых каждой точке пространства предметов соответствует одна и только одна точка пространства изображений.

СОПУТСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОТСЧЕТА — система отсчета, связанная с рассматриваемой системой тел (сплошной средой); пространственные координаты этой системы тел (часть сплошной среды) в С. с. о. не изменяются при их движении, т. е. тела покоятся относительно С. с. о. Показания часов каждого тела С. с. о. (часов, движущихся вместе с телом) наз. истинными, или *собственными* временем этого тела. Темп течения собств. времени на разных телах С. с. о. может быть разным. Напр., если тела движутся в неоднородном гравитацион. поле, то периоды маятниковых часов тел, расположенных в точках с разными ускорениями силы тяжести, будут разными. Для измерения расстояний в С. с. о., как и в любой др. системе отсчета, надо ввести эталон расстояния. Обычно эталон определяют, используя постулат теории относительности о постоянстве скорости света во всех системах отсчета. Эталон расстояния можно определить как расстояние, прошедшее светом в единицу собств. времени данного тела. Из-за зависимости собств. времени от скоростей тел (относительно инерциальной системы отсчета) и их взаимодействий эталон расстояний на этих телах могут быть различны. В случае, когда С. с. о. связана с движением одного тела, её называют также *собственной системой отсчета*.

И. К. Роговацкая

СОРБЦИЯ (от лат. sorbere — поглощать) — поглощение твердым телом или жидкостью (сорбентом) жидкости или газа (сорбата) из окружающей среды. Поглощение вещества на газовой фазе всем объемом жидкого сорбента наз. *абсорбцией*, всем объемом твердого тела — *окклюзией*. Поглощение вещества поверхностью сорбента наз. *адсорбцией*. Извлечение жидкости и-л. компонента из др. жидкости наз. *экстракцией* и.л. При С. паров пористыми телами происходит *капиллярная конденсация*. Обычно одновременно протекает неск. сорбционных процессов.

СОРЕ ПЛАСТИНКА — то же, что *зонная пластинка*.

СОРЕ ЭФФЕКТ — *термодиффузия* в растворах. Назван в честь Ш. Соре (Ch. Soret), впервые исследовавшего термодиффузию (1879).

СОСТАВНОЕ ЯДРО (компаунд-ядро) — ядерная система, образующаяся в ходе *ядерных реакций* в результате слияния налетающей частицы с ядром-мишенью. С. я. неустойчиво и через нек-рое время распадается на конечные продукты реакции. Энергия, внесенная частицей, распределяется между всеми степенями свободы С. я. подобно тому, как это происходит при нагреве тел. Вследствие статич. флуктуаций одна или неск. ядерных частиц могут приобрести энергию, превышающую её ср. значение и позволяющую им покинуть «нагретое» ядро. Этот процесс, аналогичный испарению жидкости, приводит к распаду С. я. Ср. время жизни С. я. (10^{-22} — 10^{-21} с) во много раз больше времени пролета быстрой частицы через область пространства, занимаемую ядром. Существование С. я. проявляется в резонансной энергетич. зависимости вероятности реакции — при определ. энергиях налетающей частицы наблюдаются резкие максимумы сечений реакции, соответствующие состояниям С. я. Представление о С. я. впервые высказано Н. Бором (N. Bohr) в 1936; ядея об аналогии между С. я. и нагретой жидкостью принадлежит Я. И. Френкелю; основанная на ней термодинамич. теория С. я. была впервые развита в 1936—37 Х. Бете (H. Bethe), В. Вайскопфом (V. Weisskopf) и Л. Д. Ландау.

Лит. см. при ст. *Ядерные реакции, Ядро атома*.

И. С. Шапиро

СОСТАВНЫЕ МОДЕЛИ лептонов и кварков — модели, в к-рых лептоны и кварки рассматриваются как связанные состояния нек-рых гипотетич. элементарных частиц — *преонов*. Известны три

поколения лептонов и кварков (см. *Поклонения фермионов*). С учётом цвета кварков и спиральности это составляет 45 двухкомпонентных вейлевских состояний (см. *Вейля уравнение*). Столь большое число кварков и лептонов наводит на мысль об их возможном составном характере. Существует много конкретных С. м., однако ни одна из них не обладает явным преимуществом перед другими. Одной из первых С. м. является модель Пати и Салама [4]. Заметную популярность получила модель Харари и Шуне [2], к-рая содержит мин. число преонов, однако в ней игнорируются мн. динамич. вопросы. Общ. проблемы, характерные практически для всех С. м., следующие.

Экспериментально установлено, что эфф. размер лептонов и кварков не превышает $\sim 10^{-18}$ см. Если кварки и лептоны состоят из преонов, то радиус соответствующих состояний должен быть мал, $r_0 < 10^{-18}$ см. Наиб. естеств. гипотеза заключается в том, что эти связанные состояния образуются за счёт механизма конфайнмента (пленения) век-рога «металлента», подобно тому, как обычные адроны представляют собой бесцветные связанные состояния цветных кварков и глюонов (см. *Удержание цвета*). Такое объяснение порождает, однако, следующую проблему. При $r_0 < 10^{-18}$ см естеств. масштаб массы таких состояний является величиной $m \sim \hbar/cr_0 \geq 100$ ГэВ. Между тем кварки и лептоны имеют значительно меньшую массу.

Ситуация обостряется ещё больше в моделях, в к-рых не запрещены переходы между фермионами разных поколений за счёт простого перераспределения в них преонов, и особенно в моделях, где благодаря такому же механизму возможны переходы кварк-лептон. В этих моделях радиус r_0 должен быть очень мал, и соответственно масса связанных состояний очень велика. Напр., в моделях, в к-рых кварки и лептоны образуются из одних и тех же преонов, для того чтобы избежать быстрого распада протона, r_0 должен по порядку величины совпадать со шкалой т. н. *великого объединения*, т. е. естеств. масштаб массы связанных состояний должен быть $\geq 10^{16}$ ГэВ.

Возможный выход из положения состоит в том, что глобальная киральная симметрия металлентного сильного взаимодействия не нарушена спонтанно на преонном уровне, в отличие от обычной киральной симметрии, к-рая, как известно, нарушается на кварковом уровне. Тогда связанные состояния преонов с фермионами квантовыми числами остаются безмассовыми, но зато отсутствуют безмассовые псевдоскалярные *голдстоуновские бозоны* — аналог пионов в обычной квантовой хромодинамике.

В работах [3—4] было указано, что если киральная преонная симметрия не нарушена, то должна существовать определённая связь между т. н. *аномалиями* в дивергенциях токов, построенных из преонов, и токов с теми же квантовыми числами, построенных из кварков и лептонов (т. н. *согласование аномалий*). В работе [4] условие сокращения аномалий на преонном и кварк-лептонном уровнях использовалось в конкретной модели для доказательства существования в ней числа поколений, равного трём. В работе т. Хофста [3] был продемонстрирован весьма общий характер подобных условий и показано, что они накладывают жёсткие ограничения на конкретный вид составных моделей. В этой же работе сформулировано дополнение, требование к требованию согласования аномалий на преонном и кварк-лептонном уровнях — т. н. *условие отщепления*. Последнее состоит в том, что если масса к.-н. преона стремится к бесконечности, все связанные состояния, содержащие этот преон, выпадают из спектра, а оставшиеся состояния должны удовлетворять требованию согласования аномалий. Следует отметить, что условие отщепления представляется значительно менее обоснованным по сравнению с осн. условием согласования аномалий.

В качестве примера применения условия согласования аномалий можно привести составную модель, предложенную в работе [5]. В этой модели предполагается, что кварки и лептоны принадлежат одному определ. представлению группы великого объединения, а преоны — её синглярному представлению. Предполагалось также, что составные фермионы являются трёхпреонными композициями. Оказалось, что при этих гипотезах условие согласования аномалий т. Хофста однозначно приводит к группе *SU(8)*. Эта группа может включать в виде связанных состояний преонов три поколения фермионов с правильными квантовыми числами.

Лит.: 1) Pati J. C., Salam A., Lepton number as the fourth «color», «Phys. Rev.», 1974, v. D 10, p. 275; 2) Hara G. H., A schematic model of quarks and leptons, «Phys. Lett.», 1970, v. 36 B, p. 83; 3) Hara G. H., A composite model of leptons and quarks, там же, p. 87; 3) Hoff G. G., Cargèse summer institute lectures, 1979; 4) Ансельми А. А., Проблема семейства частиц и составные *SU(5)* декуплеты, «Лисьма в ЖЭТФ», 1980, т. 31, с. 150; 5) то же, Проблема поколений частиц и матричная структура лептонов и кварков, «ЖЭТФ», 1981, т. 80, с. 40; 5) Чкаев Е. И. Д. И. Л., Кварк-лептонные семейства: от *SU(5)* к *SU(8)*-симметрии, «Лисьма в ЖЭТФ», 1980, т. 32, с. 58.

СОХРАНЕНИЯ ЗАКОНЫ — физ. закономерности согласно к-рым численные значения век-рых физ. величин не изменяются со временем в любых процессах или в определ. классе процессов. Полное описание физ. системы возможно лишь в рамках динамич. законов, к-рые детально определяют изменение состояния системы с течением времени. Однако во мн. случаях динамич. закон для данной системы неизвестен или слишком сложен. В такой ситуации С. з. позволяют сделать век-рые заключения о характере поведения системы. Важнейшими С. з., справедливыми для любых изолиров. систем, являются законы сохранения энергии, импульса, угл. момента, электрич. заряда. Кроме всеобщих существуют С. з., справедливые лишь для огранич. классов систем и явлений.

Большую роль С. з. играют в квантовой теории, в частности в теории элементарных частиц. С. з. определяют *отбора правила*, согласно к-рым реакции с частицами, к-рые привели бы к нарушению С. з., не могут осуществляться в природе. В дополнение к перечисленным С. з., имеющимся и в физике макроскопич. тел, в теории элементарных частиц возникло много специфич. С. з., позволяющих интерпретировать наблюдаемые на опыте правила отбора. Таков, напр., закон сохранения *барионного числа*, выполняющийся с очень высокой точностью во всех видах фундам. взаимодействий. Существуют и приближённые С. з., выполняющиеся в одних процессах и нарушающиеся в других. Такие С. з. имеют смысл, если можно указать класс процессов, в к-рых они выполняются. Напр., законы сохранения *странности*, *изотопического спина*, *пространственной чётности* строго выполняются в процессах, протекающих за счёт *сильного взаимодействия*, но нарушаются в процессах *слабого взаимодействия*. Эл.-магн. взаимодействие нарушает закон сохранения изотопич. спина. Т. о., исследуя элементарных частиц вновь напоминали о необходимости проверить существующие С. з. в каждой области явлений. Так, считавшийся абсолютно строгим закон сохранения барионного числа на основании теоретич. аргументов подвергается сомнению. Проводятся сложные эксперименты, имеющие целью обнаружить возможные слабые нарушения этого закона.

С. з. тесно связаны со свойствами *симметрии* физ. систем. При этом симметрия понимается как инвариантность физ. законов относительно нек-рой группы преобразований входящих в них величин. Наличие симметрии приводит к тому, что для данной системы существует сохраняющаяся физ. величина (см. *Нетер теорема*). Т. о., если известны свойства симметрии системы, можно найти для неё законы сохранения, и наоборот.

Как отмечалось, законы сохранения энергии, импульса, угл. момента обладают всеобщностью. Это

обусловлено тем, что соответствующие симметрии можно рассматривать как симметрии пространств-времени (мира), в к-ром движутся материальные тела. Так, сокращение энергии связано с однородностью времени, т. е. с инвариантностью физ. законов относительно изменения начала отсчёта времени; сохранение импульса и момента связаны соответственно с однородностью пространства (инвариантность относительно пространственных сдвигов) и изотропностью пространства (инвариантность относительно вращений пространства). Поэтому проверка механич. С. в. есть проверка соответствующих фундам. свойств пространства-времени. Долгое время считалось, что кроме неречисленных элементов симметрии пространство-время обладает зеркальной симметрией, т. е. инвариантно относительно пространственной инверсии. Тогда должна была бы сохраняться пространственная чётность. Однако в 1957 было экспериментально обнаружено несохранение чётности в слабом взаимодействии, поставившее вопрос о пересмотре взглядов на глубокие свойства геометрии мира.

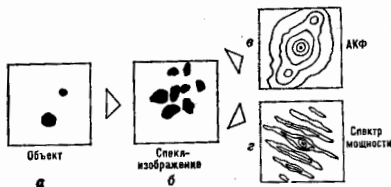
В связи с развитием теории гравитации (см. *Тяготение*) намечается дальнейший пересмотр взглядов на симметрии пространства-времени и фундаментальные С. в. (в частности, на законы сохранения энергии и импульса).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика, 4 изд., М., 1988; Фейнман Р., Характер физических законов, пер. с англ., М., 1988; Вигнер Е., Этюды о симметрии, пер. с англ., М., 1971; **СПЕКТЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ** в астрономии — метод наземных оптич. наблюдений, основанный на анализе тонкой структуры «мгновённых» изображений космич. объектов. С.-и. позволяет получать высокое угл. разрешение при наличии атм. искажений изображения.

В отсутствие атмосферы разрешение идеального (без аббераций) телескопа определяется усл. размером дифракц. кружка, т. е. равно $1,22 \lambda/D$ радian (где λ — длина волны, D — диаметр объектива); шаг, при δ -метрового оптич. телескопа эта величина $\approx 0,02''$. Из-за искажений волнового фронта в атмосфере и в результате «мгновённого» изображения точки в реальном телескопе распадается на множество дифракц. пятен (с характерным размером λ/D), распределённых в области размером $d \sim 1''$ (спекл-изображение). Вместе с изменением атм. искажений изменяется и структура изображения (характерное время $\approx 0,02$ с), поэтому при обычных для астрономии экспозициях она размывается. В результате изображение точки представляет собой пятно размером d , т. е. разрешение телескопа существенно ухудшается. При помощи анализа тонкой структуры серии изображений, зарегистрированных с короткой ($\approx 0,02$ с) экспозицией, в методе С.-и. удаётся достичь разрешения наземных телескопов до дифракц. предела ценой потери чувствительности.

В 1970 А. Лабейри (A. Labeyrie) показал, что наблюдаемые в «мгновённых» изображениях звезд дифракц. пятна в принципе тождественны спеклам, наблюдаемым при освещении предметов лазером, и возникают за счёт интерференции в фокусе телескопа волны, полученных в атмосфере случайные фазовые задержки. Из-за малости этих задержек спекл-изображений могут наблюдаться не только в монохроматич. свете, но и в достаточно широком диапазоне спектра. Лабейри предложил обрабатывать серии спекл-изображений, вычисля их ср. спектр мощности или автокорреляц. ф-цию (АКФ) (см. *Случайный процесс*). Пусть, напр., наблюдается *тепная двойная звезда* (рис., а; негатив); её спекл-изображение (б) состоит из двух идентичных картин, образованных каждым из компонентов. Для отделения характеристик объекта от случайных деталей единичных изображений усредняют АКФ по большому числу изображений (от неск. десятков до миллионов). Усреднённая АКФ (рис., в; приведены линии равных значе-

ний) будет содержать 3 максимума: самый большой в начале координат и 2 боковых, соответствующих совпадению сдвинутых спеклов яркого компонента со спеклами слабого компонента. Расстояние между главным и боковыми максимумами равно расстоянию между компонентами двойной звезды. В спектре мощности (рис., г; приведены линии равных значений)



боковыми максимумами соответствует система полос. Период полос обратно пропорционален расстоянию между компонентами. По контрасту полос можно определить отношение интенсивностей излучения компонентов.

Оси. ур-ние С.-и. можно получить из следующих соображений. Если $O(\alpha_1, \alpha_2)$ — распределение интенсивности света в объекте наблюдения, $P(\alpha_1, \alpha_2)$ — распределение интенсивности в спекл-изображении точки, то распределение интенсивности в изображении объекта $I(\alpha_1, \alpha_2)$ представляет собой свёртку этих ф-ций (α_1, α_2 и β_1, β_2 — угл. координаты):

$$I(\alpha_1, \alpha_2) = \iint O(\beta_1, \beta_2) P(\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2) d\beta_1 d\beta_2 \equiv O \odot P.$$

Из определения АКФ

$$C(\beta_1, \beta_2) = \iint I(\alpha_1, \alpha_2) I(\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2) d\alpha_1 d\alpha_2 \equiv I \otimes I$$

(свёртки \odot и \otimes отличаются знаками переменных интегрирования во 2-м сомножителе, для симметричных ф-ций они совпадают) получаем осн. ур-ние С.-и.:

$$\langle I \otimes I \rangle = (O \otimes O) \langle P \otimes P \rangle,$$

где угл. скобки обозначают усреднение по реализациям случайной ф-ции P (по кадрам). Зная из наблюдений $\langle I \otimes I \rangle$ и определив $\langle P \otimes P \rangle$ по наблюдениям точечного источника (звезды), находим $O \otimes O$ — АКФ объекта, по к-рой можно судить о его тонкой структуре, но нельзя, вообще говоря, восстановить исходное изображение.

В 1970-х гг. была создана теория С.-и., т. е. рассчитаны свойства спекл-изображений, их связь с характеристиками атм. неоднородностей, телескопа и метода регистрации. Было показано, что спекл-интерферометр есть разновидность звёздного *интерферометра Майкельсона*, а спеклы суть хаотич. интерференц. полосы. Чувствительность всех звёздных интерферометров ограничена квантовой природой света. Когда за время экспозиции в одном спекле регистрируется в среднем меньше одного фотона, то спеклов уже не видно, но АКФ всё же удаётся измерить за счёт накопления большого числа (до 10^8) кадров. Необходимость получить приемлемое отношение сигнала к шуму за время наблюдений задаёт предел чувствительности, к-рый сильно зависит как от атм. условий, так и от характера объекта. На крупных телескопах методом С.-и. наблюдают звёзды не слабее 16⁻¹⁸м.

Наблюдения методом С.-и. начаты в 1972. Вначале спекл-изображения регистрировали на фотоплёнку, ныне преим. используют телевиз. счётчики фотонов. АКФ вычисляют, как правило, в реальном времени с

помощью электронного цифрового коррелятора. Измерены угл. диаметры неск. десятков звезд на разных длинах волн, а также угл. размеры нек-рых астероидов, спутников больших планет и др. объектов. Наблюдались мелкие детали солнечной поверхности. Наиб. число результатов получено в области излучения двойных звезд: выполнено более 8000 измерений с точностью до 0,001", открыто ок. 300 тесных двойных звезд, определены орбиты неск. систем и вычислены массы компонентов. Методом С.-и. проводят наблюдения также в ИК-диапазоне спектра на длинах волн до 5 мкм. Так были исследованы околосолнечные пылевые оболочки и диски, открыты холодные компоненты в двойных системах.

С.-и. развивается в неск. направлениях. Разрабатываются способы восстановления истинного изображения, а не АКФ. Предложено неск. методов, в т. ч. метод замкнутых фаз, аналогичный радиоастр. *апerture synthesis*, и метод тройных корреляц. ф-ций. Чувствительность их хуже, чем в обычной С.-и. Обработка данных требует большого объема вычислений, что и сдерживает внедрение этих методов, хотя нек-рые астр. приложения уже имеются.

Повышается точность измерений. В частности, предложено измерять смещение спеклов в зависимости от длины волны, чтобы на существующих телескопах получить эфф. разрешение до 0,0001".

С целью повышения разрешения в оптическом и ИК-диапазонах создаются интерферометры, образованные независимыми телескопами с базами в десятки и сотни метров. Кроме измерения угл. диаметров в нек-рых приборах ставится задача измерения координат источников с точностью до 0,01".

Ведется предварит. разработка космич. интерферометров с большими базами, к-рые намного превосходят наземные интерферометры по чувствительности.

Лит.: Labeugie A., *Stellar interferometry methods*, «Ann. Rev. Astron. and Astrophys.», 1978, v. 16, p. 77; Франко в. М., *Оптика спеклов*, пер. с франц., М., 1980; B o d i n g t. P., *The effects of atmospheric turbulence in optical astronomy*, «Prog. in Optics», 1981, v. 19, p. 283; Токовянн А. А., *Звездные интерферометры*, М., 1988. А. А. Токовянн.

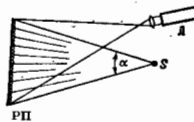
СПЕКЛЫ (от англ. speckle — пятнышко, крапинка) — пятнистая структура в распределении интенсивности когерентного света, отраженного от шероховатой поверхности, неровности к-рой соизмеримы с длиной волны света λ , или прошедшего через среду со случайными флуктуациями показателя преломления. С. возникают вследствие *интерференции света*, рассеянного отд. шероховатостями объекта. Т. к. поверхность предмета освещается когерентным светом, то интерферируют все рассеянные лучи и интерференц. картина имеет не периодическую, а хаотич. структуру. На рис. 1 представлена фотография спекл-структуры, возникающей при рассеянии высокоинтенсивного (лазерного) пучка света, проходящего через матовое стекло.

Можно различить два случая образования С. — в пространстве предметов и в пространстве изображений. В *пространстве предметов* С. возникают т. н. *объективные* С. Свет от лазера (рис. 2)



Рис. 1. Фотография объективных спеклов.

Рис. 2. Схема образования объективной спекл-структуры: Л — лазер; РП — рассеивающая поверхность; S — точка наблюдения.



освещает шероховатую, диффузно рассеивающую поверхность; полная амплитуда световой волны в точке наблюдения является суммой векторов амплитуд волн, рассеянных всеми точками освещенной поверхности. Эти волны имеют случайные фазы, и в результате их сложения получается случайная результирующая амплитуда. При изменении координат точки наблюдения полная амплитуда (и интенсивность) принимает различные, также случайные значения, что и обуславливает появление С. Поперечное смещение точки наблюдения (без изменения расстояния до рассеивающей поверхности) ведёт к быстрому изменению равености хода между интерферирующими волнами и, соответственно, к маломасштабным изменениям интенсивности. Продольное смещение точки наблюдения ведёт к относительно медленным изменениям равености хода и, соответственно, к относительно крупномасштабным флуктуациям интенсивности. Др. словами, отдельные С. имеют вытянутую вдоль направления наблюдения сигарообразную форму.

Средний поперечный диаметр спекла

$$d = 1,22\lambda/\alpha, \quad (1)$$

где α — угл. диаметр освещенной когерентным светом шероховатой поверхности. Средний продольный размер спекла

$$l = 4\lambda/\alpha^2. \quad (2)$$

В пространстве изображений образуются т. н. *субъективные* С. При наблюдении субъективных С. изображение предмета оказыва-

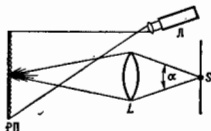


Рис. 3. Схема образования субъективной спекл-структуры (структура наблюдения): Л — лазер; РП — рассеивающая поверхность; L — линза; S — точка наблюдения.

Рис. 4. Гало дифракции с полосами Юнга.

ется продолгуемой структурой спекл-структуры. В этом случае ср. размеры С. также описываются ф-лами (1) и (2), где α — угл. размеры линзы, образующей изображение (рис. 3). Субъективные С. обусловлены интерференцией волн, исходящих из всех элементов микроструктуры поверхности объекта в пределах являта разрешения оптич. системы, т. е. предполагается, что оптич. система не разрешает микроструктуру поверхности.

Спекл-структура изображений проявляется как при фотографировании в когерентном свете, так и в голографии. В последнем случае размеры С. также определяются по ф-лам (1) и (2), где α — угл. размеры голограммы.

Спеклы мешают рассматриванию объектов, освещенных когерентным светом, поэтому для их устранения используют разл. методы, сводящиеся либо к существ. уменьшению размеров С., либо к усреднению спекл-структуры во времени при случайном изменении распределения фазы волн, освещающей объект (или голограмму). Но С. имеют и широкое практич. применение в спекл-фотографии и *спекл-интерферометрии* [1—3, 5] для регистрации перемещений и деформаций объектов с диффузной поверхностью, для измерения шероховатостей поверхности, в астрономия

оператору с формальными решениями ур-ния $Ax = \lambda x$, отвечающими непрерывному спектру; такие решения не принадлежат \mathcal{H} . Напр., для системы с одной степенью свободы, координата k -рой может принимать значения на всей оси $R = (-\infty, +\infty)$, \mathcal{H} в координатном представлении реализуется как пространство $L^2(R)$ квадратично интегрируемых ф-ций $\psi(q)$ на R . Оператор импульса $p = -\hbar d/dq$ имеет непрерывный спектр, совпадающий с R . Решениями ур-ния $p\psi_k(q) = \lambda\psi_k(q)$ являются плоские волны $\psi_k(q) = e^{i\lambda q/\hbar}$; поскольку в пространстве $L^2(R)$ их норма $\langle \lambda | \lambda \rangle = (2\pi)^{-1} \int \psi_k(q)\psi_k(q) dq$ расходится, они не принадлежат $L^2(R)$ и наз. обобщёнными собственными и векторами. Комбинация $|\lambda\rangle = \langle \lambda|$ является аналогом проектора на обобщённый собств. вектор $|\lambda\rangle$, а спектральное разложение

$$p = \int d\lambda \lambda |\lambda\rangle \langle \lambda| -$$

аналогом разложения (*) для случая непрерывного спектра: для любого вектора $\psi(q) = |\psi\rangle \in L^2(R)$ име-

$$p\psi(q) = \int d\lambda \lambda |\lambda\rangle \langle \lambda| \psi = \int d\lambda \lambda \exp(-i\lambda q/\hbar) (2\pi)^{-1} \int dq' \exp(i\lambda q'/\hbar) \psi(q') = -i\hbar d\psi(q)/dq.$$

Эта конструкция служит только моделью математически строгого определения спектрального разложения операторов с непрерывным спектром ([3], [4]). В большинстве квантово-механ. задач дискретный и непрерывный участки спектра не пересекаются, а случаи, когда точки дискретного спектра погружены в непрерывный, считаются эзотрическими. Простейший пример такой ситуации — осциллирующий и медленно убывающий с расстоянием потенциал (т. н. потенциал Вигнера — фон Неймана).

Лит.: 1) Хейман и Ш. Квантовые векторные пространства, пер. с англ., М., 1963; 2) Дирак П. А. М., Принципы квантовой механики, пер. с англ., 2 изд., М., 1979; 3) Рид М., Сэймон Б., Методы современной математической физики, т. 1, Фундаментальный анализ, пер. с англ., М., 1977; 4) Фойн Невин И., Математические основы квантовой механики, пер. с нем., М., 1964. В. Ш. Цолов.

СПЕКТРАЛЬНАЯ АППАРАТУРА РЕНТГЕНОВСКАЯ — см. Рентгеновская спектральная аппаратура.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ — узкий (почти монохроматический) пик в спектре испускания (С. л. испускания) либо провал в спектре пропускания (С. л. поглощения) объекта. С. л. характерны для разл. спектров, однако чаще всего этот термин применяют к квантовым системам. Положение С. л. в спектре обычно определяют длиной волны λ , частотой $\nu = c/\lambda$ либо энергией фотона $h\nu$.

С. л. квантовой системы (атома, ядра, молекулы, кристалла и т. п.), как правило, отвечает переходу между её дискретными уровнями энергии i и k и кроме длины волны характеризует энергию перехода и квантовыми числами нижнего i и верхнего k уровней, вероятностью излучат. перехода (*Зинштейна коэффициентом*) A_{ki} либо силой осциллятора f_{jk} . С. л., возникающие вследствие оптически разреженных (электрических дипольных) переходов, наз. разрешёнными. Если электрический дипольный переход между уровнями запрещён *забора правилами*, С. л. наз. запрещённой.

Распределение интенсивности в С. л. наз. её контуром; его характеризуют ширина спектральной линии и её сдвиг (см. *Контур спектральной линии*). Мия. ширина С. л. наз. естественной или радиационной, она реализуется при квантовых переходах в изолиров. атоме или молекуле (системе неподвижных и невазаимодействующих молекул). Уширение спект-

ральны линий возникает вследствие теплового движения частиц (доплеровское уширение) и взаимодействий с окружающими частями. В некоторых случаях упругие столкновения с окружающими частями либо со стенками приводят к ступеню С. л. Чрезвычайно узкие ($\Delta\nu/\nu \sim 10^{-13}$) С. л. атомных ядер проявляются в спектрах кристаллов в результате *Мессбауэра эффекта*. Очень узкие С. л. излучения получают в стабилизированных по частоте *квантовых генераторах* микроволнового и оптического диапазонов. Весьма узкие С. л. могут наблюдаться методами *высокой лазерной спектроскопии*. Наблюдаемая ширина С. л. часто определяется *аппаратной функцией* спектрального прибора.

В электрич. поле С. л. испытывает сдвиг и расщепление (см. *Штарк эффект*), магн. поле приводит к всемагнитному расщеплению С. л. (см. *Зеемана эффект*). В электрич. поле интенсивной эл.-магн. волны также возникают сдвиг и расщепление С. л.

В таблицах и атласах С. л. чаще всего указывают длины волн, приведённые к условиям наблюдения в вакууме $\lambda_{\text{вак}}$, а иногда — в воздухе при нормальных условиях $\lambda_{\text{возд}}$ ($\lambda_{\text{возд}} = \lambda_{\text{вак}}/n$), где n — показатель преломления воздуха для длины волны $\lambda_{\text{вак}}$. Имеются системат. таблицы С. л. атомов и ионов, а также атласы С. л. большого числа молекул.

Лит.: Таблицы спектральных линий, 4 изд., М., 1977; Вегарден J. A., X-ray wavelengths, «Rev. Mod. Phys.», 1967, т. 39, № 1, p. 78; Веарден J. A., Бург А. F., Reevaluation of X-ray atomic energy levels, там же, p. 125; Кейли Р. L., Раули и Бо L. J., Atomic and ionic emission lines below 2000 angstroms. Hydrogen through krypton, Wash., 1973; Wavelengths and transition probabilities for atoms and atomic ions, Wash., 1980; Стриганов А. P., Одицова Г. А., Таблицы спектральных линий атомов и ионов, М., 1962; Е. А. Юм. **СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ** (спектральная интенсивность) в статистической физике — коэффициенты разложения временных *корреляционных функций* в интеграл Фурье. Для операторов A и B квантово-механ. системы с *гамильтонианом* H , хм. потенциалом μ и оператором числа частиц N величина С. п.

$$I_{BA}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \langle B(t)A(t') \rangle \exp(-i\omega(t-t')) d(t-t'),$$

где $\langle B(t)A(t') \rangle = \text{Sp}\{B(t)A(t')\}$ — зависящая лишь от $(t-t')$ равновесная временная корреляц. ф-ция двух операторов в *Гейзенберга представлении* $B(t) = \exp(-i\mathcal{H}t/\hbar) B \exp(-i\mathcal{H}t/\hbar)$, $\mathcal{H} = H - \mu N$, $\rho = Z^{-1} \exp(-i(H - \mu N)/kT)$ — статистич. оператор для *большого канонического распределения* Гиббса, $Z = \text{Sp} \exp(-\mathcal{H}/kT)$, Sp обозначает суммирование диагональных матричных элементов оператора. С. п. можно получить из спектральных представлений *Грина функции*, что затем позволяет вычислять временные корреляц. ф-ции. В том случае, когда A и B эрмитово сопряжённые операторы ($B = A^*$), величина $I_{A^*A} \geq 0$. Переставляемость операторов под знаком Sp определяет условие Кубо — Мартина — Швингера (R. Kubo, P. C. Martin, J. Schwinger, 1959) для С. п.:

$$I_{AB}(\omega) = I_{BA}(-\omega) \exp(-\hbar\omega/kT).$$

В более явной форме С. п. можно представить в виде суммы по всем собств. состояниям оператора \mathcal{H} (m и n — квантовые числа):

$$I_{BA}(\omega) = 2\pi \sum_{m,n} B_{nm} A_{nm} \exp(-\epsilon_m/kT) \delta(\epsilon_m - \epsilon_n - \hbar\omega).$$

Здесь ϵ_m и ϵ_n — собств. значения оператора \mathcal{H} , B_{nm} и A_{nm} — матричные элементы операторов A и B в системе собств. ф-ций \mathcal{H} , $\delta(\epsilon_m - \epsilon_n - \hbar\omega)$ —

дельта-функция. Для систем, изучаемых в статист. физике, спектр $S_{\text{ст}}$ практически непрерывен из-за больших размеров системы в термодинамическом пределе, поэтому суммирование по m , в соответствии интегрирование по плотности состояний. В силу этого С. п. проявляет с-образный характер лишь для систем с незатухающими элементарными возбуждениями (напр., для идеального газа квазичастиц).

В случае классич. статист. механики A и B — соответствующие операторам динамические переменные, а операция $S\rho$ переходит в интегрирование по всем координатам и импульсам частиц и суммирование по числу частиц.

С. п. может быть вычислена точно лишь для простейших модельных систем, однако при её приближенном нахождении для сложных систем должны выполняться некоторые точные интегральные соотношения — т. н. *правила сумм*, к-рые служат критерием правильности выполненных аппроксимаций.

Лит. см. при ст. Грина функция в статистической физике. Д. Н. Зубов.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (стационарная) случайной функции $\{\xi_t, t \in T\}$ — дисперсия случайной амплитуды той или иной гармоники, входящей в спектральное (гармонич.) разложение ξ_t . Для более точного определения С. п. рассмотрим случаи, когда случайная ф-ция представляет собой: а) стационарную случайную последовательность (T — множество целых чисел), б) стационарный случайный процесс ($T = R^1$), в) стационарное случайное поле ($T = R^v, v > 1$). Во всех случаях ф-ция $\{\xi_t, t \in T\}$ при довольно общих условиях допускает следующее разложение на гармоники (спектральное представление):

$$\xi_t = \int_{\Lambda} \exp(it, \lambda) Z(d\lambda), \quad (1)$$

где $\Lambda = (-\pi, \pi) \subset R^1$ — для случайной последовательности, $\Lambda = R^1$ — для случайного процесса и $\Lambda = R^v$ — для случайного поля; $Z(d\lambda)$ — случайная мера (вообще говоря, комплекснозначная), определенная на подмножествах из Λ , и её значения на непересекающихся множествах не коррелированы:

$$\langle Z(A) \cdot \bar{Z}(B) \rangle = 0, \quad A, B \subset \Lambda; \quad A \cap B = 0 \quad (2)$$

[в ф-ле (1) $(t, \lambda) = t \cdot \lambda$ для случаев а и б и $(t, \lambda) = \sum_i t_i \lambda_i$ для случая в]. Из представления (1) и соотношения (2) вытекает, что корреляция $D(t_1, t_2)$ значений ξ_t в двух точках $t_1, t_2 \in T$ равна:

$$D(t_1, t_2) \equiv \langle (\xi_{t_1} - \langle \xi_{t_1} \rangle) (\xi_{t_2} - \langle \xi_{t_2} \rangle) \rangle = \int_{\Lambda} \exp\{i(t_1 - t_2, \lambda)\} p(\lambda) d\lambda, \quad (3)$$

где ф-ция $p(\lambda) \geq 0$, определяемая соотношением

$$\langle |Z(d\lambda)|^2 \rangle = p(\lambda) d\lambda + o(d\lambda),$$

наз. С. п. случайной ф-ции ξ_t . Из ф-лы (3) следует, что

$$p(\lambda) = \frac{1}{(2\pi)^v} \int_{R^v} \exp(-it, \lambda) D(t, 0) dt \quad (4)$$

для случайного процесса ($v = 1$) или случайного поля ($v > 1$) и

$$p(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{t=-\infty}^{\infty} \exp(-it\lambda) D(t, 0) \quad (5)$$

для случайной последовательности.

Заметим, что ф-лы (4) и (5) дают способ непосредств. нахождения С. п. $p(\lambda)$, но использующее разложение (1).

Лит.: Гихман И. И., Скороход А. В., Введение в теорию случайных процессов, 2 изд., М., 1977. Р. А. Мильос. **СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ** оптической величины, характеризующей излучение λ (напр., потока излучения, силы света), — отношение величин dX , взятой в бесконечно малом спектральном интервале $d\lambda$, содержащем данную длину волны λ , к ширине этого интервала:

$$X_{\lambda} = dX/d\lambda.$$

С. п. может быть образована не только в шкале длин волн λ , но и в др. спектральных шкалах: частот f — с обозначением X_f , волновых чисел ν — X_{ν} , их логарифмов. Зависимость С. п. фотометрич. величин X_{λ} от длин волн λ называют спектральным распределением фотометрич. величин и обозначают $X_{\lambda}(\lambda)$. Форма кривой, изображающей спектральное распределение, и положение максимума на ней зависят от выбранной спектральной шкалы. Так, с учётом функциональной связи $\lambda f = c$ (c — скорость света) между С. п. рассматриваемого оптич. излучения (напр., излучения чёрного тела при заданной темп-ре) в шкалах частот X_f и С. п. в шкале длин волн X_{λ} существует соотношение

$$X_f = \lambda^2 c^{-1} X_{\lambda}.$$

При этом длина волны λ_m , на к-рую приходится максимум ф-ции $X_{\lambda}(\lambda)$, и частота f_m , на к-рую приходится максимум ф-ции $X_f(f)$, соответствуют разным спектральным компонентам: $\lambda_{m1} m_2 \neq c$. Поэтому не имеет смысла судить о максимуме энергии в спектре по кривой спектрального распределения. В отличие от С. п. значение *спектральной чувствительности* $S(\lambda)$ прибора излучения в выбранной спектральной точке не зависит от выбора спектральной шкалы. Следовательно, совмещение максимумов ф-ций $X_{\lambda}(\lambda)$ и $S(\lambda)$ является критерием наилучшего энергетич. согласования излучателя и прибора. Таким критерием являются лишь макс. значение инварианта относительно спектральных шкал:

$$\int_0^{\infty} X_{\lambda}(\lambda) S(\lambda) d\lambda = \int_0^{\infty} X_f(f) S(f) df.$$

Понятия С. п. и спектрального распределения применяются не только в фотометрии, но и в радиоэлектронике и акустике для описания спектров источников, сигналов и шумов, в радиометрии ионизирующего излучения, в теории переноса излучения (астрофизика, тепловизика, физика плазмы) и т. п.

Лит.: Гершун А. А., Избранные труды по фотометрии и светотехнике, М., 1958; Гуревич М. М., Фотометрия. Теория, методы и приборы, 2 изд., Л., 1983; С. п. в оптике Р. А., Геофизическая фотометрия, 3 изд., М., 1977. А. С. Лыбичев. **СПЕКТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА** — характеризуется более протяжённым, чем спектральная линия, интервалом длин волн (частот). С. п. характерны для колебат. спектров молекул и спектров твёрдых тел. Могут распадаться на отд. вращат. линии. Подробнее см. *Молекулярные спектры. Спектры кристаллов*. **СПЕКТРАЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** монохроматического излучения (устар. назв. — видимость) — отношение светового потока монохроматич. излучения на длине волны λ и соответствующему потоку излучения. С. с. э. обозначается $K(\lambda)$ и имеет размерность лм/Вт. Макс. С. с. э. для дневного зрения человека $K_m = 683$ лм/Вт соответствует монохроматич. излучению с частотой $5.4 \cdot 10^{14}$ МГц ($\lambda \approx 555$ нм). Отношение $K(\lambda)/K_m = V(\lambda)$ наз. о. т. и о. т. е. л. н. о. С. с. э. (о. т. о. т. видимость) монохроматич. излучения с длиной волны λ . Т. о., $V(\lambda)$ имеет смысл относительной спектральной чувствительно-

сти зрит. системы человека, определяемой как отношение двух потоков излучения соответственно с длинами волн $\lambda_{\text{н}}^{\text{н}}$ и $\lambda^{\text{н}}$, вызывающих (в предел. условиях наблюдения) зрит. ощущение одинакового уровня. При этом $\lambda_{\text{н}}^{\text{н}}$ выбирается так, чтобы макс. значение $V(\lambda) = 1$. В результате усреднения результатов многочисл. экспериментов Международной комиссии по освещению (МКО) ещё в 1924 принята международному применению в инструментальных световых измерениях таблица значений ф-ции $V(\lambda)$ для дневного зрения (ГОСТ 8.332-73). Модельный приёмник излучения, характеристика относительной спектральной чувствительности к-рого соответствует стандартной ф-ции $V(\lambda)$, наз. стандартным фотометр. наблюдателем МКО. Т. к. ф-ция $V(\lambda)$ для зрит. системы человека установлена условно, то результаты визуального и инструментального фотометрирования (особенно для цветных излучений) могут различаться.

СПЕКТРАЛЬНАЯ СЕРИЯ — группа спектральных линий в атомных спектрах, частоты к-рых подчиняются опред. закономерностям. Линии определяются С. с. в спектрах спускаются возникают при всех разрешённых квантовых переходах с разл. нач. верх. уровней энергии на один и тот же конечный ниж. уровень (в спектрах поглощения — при обратных переходах). С. с. наиб. чётко проявляются в спектрах атомов и ионов с одним и двумя электронами во внеш. оболочке (в спектрах водорода и водородоподобных атомов, гелия и гелийподобных атомов, атомов щелочных металлов и т. д.).

Спектры атома водорода и ионов с одним электроном состоят из С. с., линии к-рых характеризуют волновые числа:

$$\nu = Z^2 R_M \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right),$$

где n_0 и $n_1 = n_0 + 1, n_0 + 2, \dots$ — главные квантовые числа нижнего и верхнего уровней энергии, между к-рыми происходит соответствующий квантовый переход, Z — спектроскопич. символ (для нейтральных атомов $Z = 1$), $R_M = R/2\pi n c (1 + m/M) = 109737,315714/(1 + m/M)$, m и M — массы электрона и ядра атома соответственно, R — *Ридберга постоянная*. Для атома водорода $R_M = 109677,583436 \text{ см}^{-1}$. В зависимости от n_0 для водородоподобных систем получаются различные С. с.: при $n_0 = 1$ — серия Лаймана, при $n_0 = 2$ — серия Бальмера, $n_0 = 3$ — серия Пашена, $n_0 = 4$ — серия Бракета, $n_0 = 5$ — серия Шфуада, при $n_0 = \infty$ — серия Хамфри. Линии этих серий имеют обозначения: для серии Лаймана (в порядке возрастания ν) L_1, L_2, L_3 и т. д.; Бальмера — H_1, H_2, H_3 и т. д. Расстояния между линиями С. с. с ростом n_1 уменьшаются, и С. с. сходится к границе серии (КВ-границе, соответствующей $n_1 = \infty$), за пределами к-рой находится непрерывный спектр. Серии Лаймана и Бальмера обособлены, остальные С. с. частично перекрываются. Границы первых трёх С. с. атома водорода — 912, 3648 и 6208 Å.

Атомы щелочных элементов близки по строению к атому водорода, однако они обладают более сложной энергетич. структурой. Для них выделяют в осн. 4 С. с.: $n_0 s - n_1 p$ — главная серия, $n_0 p - n_1 s$ — резкая (или первая побочная) серия, $n_0 p - n_1 d$ — диффузная (или вторая побочная) серия, $(n_0 + 1) d - n_1 f$ — фундаментальная (или серия Бергмана); здесь n_0 — гл. квантовое число осн. состояния, s, p, d и f — состояния соответствуют $l = 0, 1, 2, 3$ [эти обозначения дали названия С. с.: s (sharp) — резкая, p (principal) — главная, d (diffuse) — диффузная, f (fundamental) — фунда.ментальная].

В рентг. спектроскопии С. с. обозначают буквами K, L, M и т. д. в соответствии с уровнем (слоем) ниж. состояния ($n_0 = 1, 2, 3$ и т. д.) по мере его удаления от ядра атома (см. *Рентгеновые спектры*).

Лит.: Бете Г., Солпитер Э., Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами, пер. с англ., М., 1980; Ельянц в. в. и др. М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1982; Фриш С. Э., Оптические спектры атомов, М. — Д., 1963.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ $S(\lambda)$ приёма оптического излучения — отношение изменения сигнала на выходе приёмника (или фотометра) к потоку или энергии монохроматич. излучения, вызывающего это изменение. С. ч. есть ф-ция длины волны λ или др. спектральной характеристики оптич. излучения — частоты, волнового числа, энергии фотона. Ф-ция $S(\lambda)$ остаётся неизменной только в пределах линейного диапазона. Диапазоны приёмника или фотометра. При эксперим. определении $S(\lambda)$ на вход приёмника подают оптич. излучение в достаточно узком спектральном интервале $d\lambda$, выделяемом к-л. спектральным прибором.

Понятие С. ч. применяется также к нелинейным приёмникам оптич. излучения и даже к биол. объектам, реакция к-рых на оптич. излучение не описывается количеств. мерой. В фотобиологии С. ч. обычно наз. спектром действия. Для нелинейных приёмников С. ч. $S(\lambda)$ есть отношение реакции $R(\lambda)$ объекта к энергетич. фотометр. величине [напр., потоку излучения $\Phi(\lambda)$], характеризующей воздействующее на объект квазимонохроматич. оптич. излучение. Возможны два способа определения С. ч.: 1) при пост. значениях $\Phi(\lambda)$ применяемых квазимонохроматич. потоков излучения; 2) при одинаковой реакции приёмника на квазимонохроматич. потоки излучения. Второй способ определения не требует количеств. оценки реакций, поэтому применим и к приёмникам, к-рыми устанавливаются только одинаковое воздействие сравняваемых квазимонохроматич. потоков оптич. излучения.

Понятие не зависящей от уровня облучения или реакции относительной С. ч. $S_r(\lambda) = S(\lambda)/S_{\text{станд.}}$ применимо к приёмникам, у к-рых реакция $R(\lambda)$ связана с $\Phi(\lambda)$ ф-циями опред. вида: $R(\lambda) = \Phi(\lambda)\Psi(\Phi(\lambda))$ — по первому способу; $R(\lambda) = F[\Phi(\lambda)\Phi^n(\lambda)]$ — по второму. Здесь $\Phi(\lambda)$ и $\nu(\lambda)$ — относительные С. ч., Ψ и F — сложные ф-ции. Не всякому аддитивному приёмнику можно приписать отношение относительной С. ч., однако приёмник может обладать этой характеристикой, не будучи аддитивным. Для линейных приёмников оба способа определения относительной С. ч. эквивалентны.

В фотобиологии понятие «спектр действия» сытает тождественным понятию «С. ч.», определяяому как при одинаковом заданном уровне реакции приёмника, так и при пост. значениях квазимонохроматич. потоков оптич. излучения. Ясно, что форма кривой спектра действия может существенно зависеть от указанных способов определения и изменяться при варьировании заданного уровня и условий наблюдения реакции. Спектр действия оптич. излучения на зрит. систему человека наз. *спектральной сетевой эффе́ктивностью* монохроматич. излучения.

Существующие намерт. модели оптич. излучения в фотобiol. процессах построены по принципу одного или неск. линейных спектрально аддитивных приёмников излучения. К таким моделям, в первую очередь, относятся стандартизованные МКО и МКМВ *сетевые величии* и колориметрич. системы (см. *Колориметрия*). При этом под линейностью понимается прямая пропорциональность реакции приёмника мощности (потоку) или энергии падающего оптич. излучения. Под спектральной аддитивностью понимается арифметич. суммирование реакций, вызываемых излучением различных узких спектральных интервалов. В общем виде матем. модель линейного спектрально аддитивного приёмника выражается соотношением для редуциров. величин:

$$X = K \int_0^{\infty} X_{e,i} S_0(\lambda) d\lambda.$$

Здесь K — переводный множитель от единиц энергетич. величин к единицам, принятым в данной системе редуциров. величин; $X_{\text{ср}}$ — спектральная плотность энергетич. радиометрич. величин; $S_{ij}(\lambda)$ — не зависящая от уровня реакция ф-ция относительно С. ч. реального или модельного (идеального) приближения.

Эквивалентные $S(\lambda)$ и $S_{ij}(\lambda)$ понятия имеются и в др. областях физики, но называются др. терминами: «крявые равной громкости и «частотная характеристика чувствительности микрофона (гидрофона)» — в акустике и гидроакустике; «амплитудно-частотная характеристика» — в радиоэлектронике; «спектр дождя» — в фотобиологии; «коэф. качества ионизирующего излучения» — в радиол. безопасности.

Лит.: Сапожников Р. А., Теоретическая фотометрия, 3 изд., М., 1977; Довы и Ков. А. С., Прикладная фотометрия, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Светотехника и Инфракрасная техника, т. 5, М., 1983.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ матричных элементов матрицы рассеяния S или Грина функций в квантовой теории поля — интегральные представления типа Коши интеграла. С. п. играют большую роль в аксиоматич. подходе к квантовой теории поля (см. Аксиоматическая квантовая теория поля), в рамках к-рого построение матрицы рассеяния осуществляется без конкретных предположений о взаимодействии, присутствующих тампальтову формализму. Особенно важны С. п., к-рые удаётся получить на основе только самых общих положений квантовой теории поля, таких, как требования микропричинности, унитарности (см. Унитарности условие), релятивистской инвариантности и предположения о центре масс. Так, напр., для ф-ции Грина $G(x-y)$ на ур-нии скалярного поля ф-ция массы m

$$G(x-y) = i \langle 0 | T(\varphi(x) S \varphi(y)) | 0 \rangle = \\ = (2\pi)^{-4} \int \exp[i p(x-y)] G(p) d^4 p \quad (1)$$

(T — символ хронологич. упорядочения, p — 4-импульс поля) на этой основе установлено важное С. п. Лемана — Каллена (H. Lehmann, G. Källén):

$$G(p) = (m^2 - p^2 - i\epsilon)^{-1} + \int_{4m^2}^{\infty} I(z) dz / (z - p^2 - i\epsilon). \quad (2)$$

Здесь $I(z)$ — неотрицат. ф-ция, описывающая распределение масс возможных состояний поля, — спектральная плотность масс, к-рая выражается через матричные элементы S -матрицы.

В общем случае вся информация о взаимодействии частиц содержится в матричных элементах S -матрицы, относящихся к переходу из состояния i независимостоящих начальных частиц в состояние f независимостоящих конечных частиц с 4-импульсами p_1, \dots, p_i и p_{i+1}, \dots, p_f . Приняв во внимание закон сохранения 4-импульса (и др. следствия релятивистской инвариантности), такой матричный элемент можно записать в виде:

$$\langle f | S | i \rangle = \delta_{fi} - 2\pi i \delta^4 \left(\sum_{(i)} p_k - \sum_{(f)} p_k \right) \prod_{(i,f)} (2\epsilon_k)^{-1/2} T_{fi},$$

где амплитуда T_{fi} перехода $i \rightarrow f$ — скалярная ф-ция 4-импульсов p_k и поляризацй λ_k начальных и конечных частиц. Зависимость T_{fi} от поляризацй можно полностью выделить, представив T_{fi} как сумму членов вида: $\lambda_{i1}(\lambda_{i2}, \lambda_{i3}, \lambda_{i4}) \cdot M_{fi}(\lambda_{i1}, \lambda_{i2}, \lambda_{i3}, \lambda_{i4})$, причём λ_{i1} — определённые матричные элементы лоренц-инвариантных комбинаций, составленных из спиновых операторов. С. п. строится для скалярных ф-ций M_{fi} , называемых инвариантными амплитудами перехода $i \rightarrow f$. Зависимость M_{fi} от своих аргументов носит динамич. характер, и её существенные черты отражаются в аналитич. свойствах M_{fi} . В частном случае, когда i и в начальном, и в конечном состоянии имеется по одной частице, $M_{fi} \equiv$

$\equiv M_{11}$ связана с ф-цией Грина в (2) соотношениями

$$G(p) = (m^2 - p^2 - i\epsilon)^{-1} + (m^2 - p^2 - i\epsilon)^{-2} M_{11}(p^2), \\ I(p^2) = (p^2 - m^2)^{-1} \text{Im} M_{11}(p^2).$$

Ряд существенных сведений об аналитич. структуре M_{fi} может быть получен из общих положений квантовой теории поля, но зависящих от конкретной модели взаимодействия.

Прежде всего, использование микропричинности и нек-рых предположений о свойствах спектра масс приводит к утверждению, что всякая инвариантная амплитуда является нек-рым граничным значением аналитич. ф-ции, зависящей только от лоренц-инвариантных комбинаций 4-импульсов p_k . Это граничное значение получается, когда квадрат полной энергии

$$s = \left(\sum_{(i)} p_k \right)^2 = \left(\sum_{(f)} p_k \right)^2$$

стремится к действит. оси сверху из области аналитичности, где он комплексен и имеет положительную мнимую часть: $s = Re s + i\epsilon$, $\epsilon \rightarrow +0$. Инвариантные амплитуды обладают, кроме того, свойством перекрёстной симметрии. Оно состоит в том, что амплитуды реал. каналов процесса взаимодействия ($i + j$) частиц, т. е. амплитуды, описывающие переходы с реал. распределением данных ($i + j$) частиц на начальные и конечные, являющиеся различными граничными значениями одной общей аналитич. ф-ции F . Амплитуда M_{α} каждого канала (α) получается из F , когда один из аргументов F — квадрат полной энергии в данном канале, s_{α} устремлён к действит. оси сверху, а остальные аргументы принимают значения в ф-ии области канала.

Условие унитарности S -матрицы позволяет установить, где $\text{Im} F$ известно отлична от нуля. В каждом канале (α) инвариантная амплитуда M_{α} как ф-ция s_{α} имеет полюсы, соответствующие возможным одночастичным состояниям, и («фазический») разрез, соответствующий многочастичным состояниям в этом канале. Характеристики этих особенностей — вычаты в полюсы и скачки на физ. разрезах — могут быть определены через матричные элементы S -матрицы с помощью той же унитарности. Напр., т. и. абсорбционная часть амплитуды (т. е. скачок амплитуды на физ. разрезе) равна

$$\Delta M_{fi} \equiv M_{fi}(s+i\epsilon) - M_{fi}(s-i\epsilon) = \\ = \sum_n \int d\Gamma_n M_{fn}(s+i\epsilon) M_{in}^*(s-i\epsilon),$$

где в правой части проводится суммирование по всем возможным промежуточным состояниям (n) и интегрирование по фазовому объёму в пространстве импульсов каждого состояния ($d\Gamma_n$ — элемент фазового объёма). Если иных особенностей, кроме требуемых унитарностью, у M_{fi} нет, интеграл Коши в комплексной плоскости s_{α} представляет собой С. п. для $M_{fi}(s_{\alpha})$. Такая простая структура особенностей и составляет отличие С. п. от более общих дисперсионных соотношений. Как показывают результаты исследований амплитуд переходов с $i + j \geq 3$, в частности примеры из теории возмущений, дисперсионные соотношения для амплитуд этих переходов могут иметь т. н. аномальные разрезы, скачки на к-рых не определяются по условию унитарности. Так, для амплитуды упругого рассеяния M_{22} на основе общих положений теории удалось доказать лишь С. п. по квадрату полной энергии s при существенных ограничениях на остальные аргументы M_{22} ; квадраты масс частиц и инвариантную передачу импульса t . Однако ввиду их ясного физ. смысла С. Мандельштама (S. Mandelstam) предложено принять без доказательств двойные С. п. по s и t для M_{22} хотя бы как основу простой теоретич. модели процесса взаимодействия. Если

для описания перехода частиц 1, 2 в частицы 3, 4 — вستی инвариантные переменные

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_2)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2,$$

причём s, t, u связаны соотношением

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2$$

и являются квадратами полной энергии в каналах, где в качестве начальных выступают соответственно частицы 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, то т. е. двойное С. п. Маделстама приобретает вид:

$$M_{22} = F(s, u, t) = \frac{1}{\pi^2} \int_{s_0}^{\infty} ds' \int_{t_0}^{\infty} dt' \frac{\rho_1(s', t')}{(s' - s - i\epsilon)(t' - t - i\epsilon)} + \\ + \frac{1}{\pi^2} \int_{t_0}^{\infty} dt' \int_{u_0}^{\infty} du' \frac{\rho_2(t', u')}{(t' - t - i\epsilon)(u' - u - i\epsilon)} + \\ + \frac{1}{\pi^2} \int_{u_0}^{\infty} du' \int_{s_0}^{\infty} ds' \frac{\rho_3(u', s')}{(u' - u - i\epsilon)(s' - s - i\epsilon)}$$

Интегрирование здесь ведётся от фвн. порогов — квадрата суммы масс внешнего промежуточного состояния в соответствующих каналах. Такое С. п. обнаруживает неперекрстную симметрию в самом виде записи. Для описания амплитуд всех трёх каналов применяется одна Ф-ция $F(s, t, u)$, в частности один и те же определяющие её спектральные плотности ρ_k . Переход, напр., от амплитуды s -канала к амплитуде t -канала осуществляется заменой s на t , а t на s . Это соответствует тому, что частица 2 заменена на античастицу 3, а частица 3 на античастицу 2 в самом процессе. С. п. Маделстама послужило основой мн. исследований процессов сильных взаимодействий.

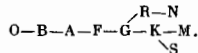
Лит.: Новый метод в теории сильных взаимодействий. Сб. статей, пер. с англ. под ред. А. М. Вронского, М., 1960; В о г о л ь б о в Н. И., М е д е в е в В. В., П о л и з а к о в М. К., Вопросы теории дисперсионных соотношений, М., 1958; Б а р т о н Г. Г., Дисперсионные методы в теории поля, пер. с англ., М., 1968. В. П. Павлов.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ КЛАССЫ — характеристики звезд, определяемые по особенностям их спектров. Различия в спектрах звезд обусловлены различиями хим. состава и физ. условий в звездной атмосфере. Для большинства звезд в видимой области характерен непрерывный спектр, на к-рый накладываются линии поглощения, а в нек-рых случаях и эмиссионные линии. Спектральная классификация носит эмпирич. характер и сводится по существу к расположению спектров звезд в последовательности, вдоль к-рых спектральные линии одних хим. элементов и соединений усиливаются, а другие ослабевают. Эти последовательности в осн. отражают зависимость спектров от *эффективной температуры* звезд. Сходные спектры объединяются в С. к., внутри к-рых, в свою очередь, выделяются подклассы. Спектральная классификация основывается на общих характеристиках спектра и на определении относительной интенсивности фиксированных спектральных линий. Критерии классификации могут изменяться в зависимости от области спектра и разрешения спектров.

Качественно изменение характерных свойств спектров с ростом темп-ры звезд может быть описано следующим образом. Для наиб. холодных звезд характерны молекулярные полосы и линии нейтральных атомов. По мере возрастания темп-ры происходит диссоциация молекул и полосы вначале ослабевают, а затем исчезают. Одновременно происходит ослабление линий поглощения, возникающих при переходах с осн. уровней нейтральных атомов. Интенсивность линий, соответствующих переходам с возбужденных уровней нейтральных атомов, с ростом темп-ры усиливается, достигает макс.

симула, а затем уменьшается из-за ионизации. Линии ионов также достигают максимума в определ. месте спектральной последовательности; его положение определяется темп-рой, при к-рой происходит следующая стадия ионизации. Положение максимумов интенсивности линий нейтральных и ионизов. атомов зависит от потенциала ионизации и потенциала возбуждения уровня, с к-рого происходит переход, создающий линию. Т. о., при продвижении вдоль спектральной последовательности от холодных звезд к горячим происходит смена линий и максимумов интенсивности линий, соответствующая нарастанию потенциалов ионизации и возбуждения. При этом линейчатые спектры объединяются, т. к. линии высокоионизованных и трудноионизируемых атомов расположены в недоступной наземным наблюдениям дальней УФ-области спектра ($\lambda < 3000 \text{ \AA}$).

История спектральной классификации звезд восходит к И. Фраунгоферу (J. Fraunhofer), обнаружившему в мач. 19 в. разлечения в спектрах неск. исследованных им ярких звезд. Первые попытки выработать систему классификации спектров были предприняты в сер. 19 в. Дж. Б. Донати (G. B. Donati) и А. Секки (A. Secchi). Решающий этап в разработке спектральной классификации связан с созданием в 1885—1924 в Гарвардской обсерватории (США) каталога звездных спектров, для к-рого была выработана система классификации. С. п. определ. модификации эта система существует и поныне. Она известна как гарвардская классификация (или HD). В HD классифицировано ок. $2 \cdot 10^5$ звезд. Она основывается на виде и интенсивности спектральных линий и отражает зависимость степени ионизации разл. элементов от темп-ры. В этой системе все спектры разбиты на классы



Ветвления классификации после класса G вызвано различием в хим. составе звезд. С. к. O, B, A иногда называют раиними, K и M — людиними. С. к. разделены на подклассы, обозначаемые араб. цифрами от 0 до 9, напр. V3. Для обозначения особенностей спектров используется система префиксов и суффиксов, напр. dM6e (префикс d означает спектр, характерный для карликов, суффикс e — наличие эмиссионных линий).

Следующий важный шаг в развитии спектральной классификации связан с учётом зависимости спектров от *светимости* звезд, что нашло выражение в разработке в 1940-х гг. двумерной иерархической классификации (MK, или MKK; от имён создателей — У. У. Морган (W. W. Morgan), Ф. Ч. Киван (P. C. Keenan), Э. Келман (E. Kellman)). Иерархическая классификация звездных спектров является основной. В этой системе кроме температурного С. к. (в пределах $\pm 0,5$ подкласса, совпадающего с гарвардским) каждой звезде присписывается один из пяти *светимости классов*, зависящий от её абс. *звёздной величины* (светимости). Иногда в МК выделяется класс углеродных звезд (C), объединяющий классы R и N гарвардской классификации. Основой иерархической классификации является набор стандартных звезд. Классификация в системе MK, как и в др. классификац. системах, осуществляется путём сравнения со спектрами стандартных звезд, снятыми на том же инструменте и с той же дисперсией. Критерием классификации является отношение интенсивностей близкорасположенных спектральных линий. Существуют списки стандартных звезд и атласы их спектров, иллюстрирующие критерии классификации. Точность спектральной классификации, к-рая определяется путём сравнения оценок С. к., полученных разл. авторами, достигает $\pm 0,6$ спектрального подкласса. В системе MK классифицировано ок. 10^5 звезд и существует программа двумерной классификации всех звезд каталога HD.

С. к. звезда можно поставить в соответствие показателю цвета, к-рые также определяются темп-рой. Связь между эфф. темп-рами звезд гл. последовательности (V класс светимости), С. к. в системе МК и показателями цвета в фотометрич. системе Джонсона (см. *Астрофотометрия*) приведена в табл.

Эффективные температуры (T_e) и показатели цвета (C_b) звезд V класса светимости (по Th. Schmidt-Kaler, 1982)

Спектральный класс	$T_e, 10^4 \text{ K}$	C_b , звездная величина	Спектральный класс	$T_e, 10^4 \text{ K}$	C_b , звездная величина
O3	52,5	(U-B) ₀	F0	7,20	0,30
4	48,0	-1,20	2	6,80	0,35
5	44,5	-1,19	5	6,44	0,44
6	41,0	-1,17	8	6,20	0,52
7	38,0	-1,15	G0	6,03	0,58
8	35,0	-1,13	2	5,88	0,63
9	33,0	-1,12	8	5,57	0,74
В0	30,0	-1,08	K0	5,25	0,81
1	25,4	-0,95	1	5,00	0,86
2	22,0	-0,84	4	4,80	0,91
3	18,7	-0,71	3	4,73	0,96
4	15,4	-0,58	4	4,59	1,05
5	14,0	-0,50	5	4,35	1,15
6	13,0	-0,43	7	4,06	1,33
7	11,9	-0,33			(R-J) ₀
8	10,5	-0,20	M0	3,85	0,92
		(E-B) ₀	1	3,72	1,02
A0	9,52	-0,02	2	3,58	1,17
1	9,23	0,01	3	3,47	1,30
2	8,97	0,05	4	3,37	1,43
3	8,72	0,08	5	3,24	1,61
4	8,20	0,15	6	3,05	1,93
5	7,85	0,20	7	2,94	2,1
6	7,58	0,23	8	2,84	2,4

Количественно осн. закономерности изменения спектров звезд, лежащие в основе спектральной классификации, описываются (при термодинамич. равновесии) распределением Больцмана по степеням возбуждения атомов:

$$\frac{n_{r,k}}{n_{r,i}} = \frac{g_{r,k}}{g_{r,i}} \exp \left[\frac{(\epsilon_{r,i} - \epsilon_{r,k})}{kT} \right] \quad (1)$$

и Саха формулой, определяющей степень ионизации атомов:

$$\frac{n_{r,i}}{n_r} p_e = \frac{2u_{r,i}}{u_r} (2\pi m_e)^{3/2} (kT)^{3/2} / h^3 \exp(-\chi_r/kT). \quad (2)$$

В (1) и (2) $n_{r,k}$ и $n_{r,i}$ — концентрация атомов в стадных ионизации r и возбуждения уровней k и i соответственно; n_r и $n_{r,i}$ — концентрация ионов в последов. стадных ионизации r и $r+1$; $g_{r,k}$ и $g_{r,i}$ — статистич. веса уровней k и i ; $\epsilon_{r,k}$ и $\epsilon_{r,i}$ — энергии возбуждения уровней; χ_r — ионизацион. потенциалы; $u_r = \sum_{k=1}^g g_{r,k} \exp(\epsilon_{r,k}/kT)$ —

сумма по состояниям g раз ионизованного атома; p_e — электронное давление. Применение ур-ний (1) и (2) позволило М. Саха (M. Saha) в 1920—21 объяснить спектральную последовательность звезд как ионизацион. последовательность. В соответствии с (1) и (2) состояние возбуждения и ионизации в осн. определяется темп-рой. Однако из ф-ды (2) следует, что состояние ионизации зависит и от электронного давления. В свою очередь, p_e связано с величиной ускорения силы тяжести в атмосфере g : при данной темп-ре в атмосфере звезды гиганта с малым g степень ионизации выше, чем в атмосфере звезды-карлика с большим g . Кроме того, величина g по-разному влияет на ионизованные и нейтральные атомы. Поскольку светимость звезды L пропорциональна ее массе M в нек-рой степени s , $L \sim M^s$ (масса — светимость зависимость), а $L \sim R^2 T_e^4$ (R — радиус, T_e — эфф. темп-ра звезды), то $g \sim L^{0,5/s}$ и характер спектра оказывается связанным со светимостью

звезды. Эта связь наз. эффектом абс. величины и, и именно ее отражает класс светимости звезд в Йёрской классификации. Различия в g сказываются на виде спектра также вследствие т. н. эффектов давления, под к-рыми подразумевается взаимодействие атома с окружающими частицами, влияющее на коэф. селективного поглощения звездного вещества. На вид спектра влияют также различия в скоростях турбулентных движений в атмосферах гигантов и карликов.

В рамках Йёрской системы удаётся описать порядка 95% всех звездных спектров. Значит, часть особенностей спектров, не укладывающихся в эту схему, может быть объяснена аномалиями хим. состава или физ. характеристик объектов. Звезды с особенностями в спектрах наз. peculiarными. Для них введены спец. классы. Напр., Ap, Bp, Fp — звезды с усиленными линиями одного или неск. элементов (Hg, Mn, Si, Eu, Sr); CNO — звезды С. к. и В, у к-рых аномальна интенсивность линий С, N, O. Особая классификация введена для белых карликов.

Дальнейшее развитие спектральной классификации связано с освоением областей спектра, недоступных наземным наблюдениям, и с автоматизацией классификации.

Лит.: Мустель Э. Р. Звездные атмосферы. М., 1960; Schmidt-Kaler Th. Physical parameters of the stars, в кн.: Landolt-Börnstein. Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Bd 2, Teilband 6, В., 1982; Jaschek C., Jaschek M., The classification of stars, Cambridge, 1987. Т. Р. Юмаласон.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ — приборы для исследования спектрального состава эл.-магн. излучений по длинам волн (в оптич. диапазоне 10^3 — 10^8 нм); см. *Спектры оптические*, находящая спектральные характеристики излучателей и объектов, взаимодействующих с излучением, а также для спектрального анализа.

Принцип действия большинства С. п. можно пояснить с помощью имитатора, изображенного на рис. 1. Форма отверстия в равномерно освещенном экране I соответствует ф-ции $f(\lambda)$, описывающей исследуемый спектр — распределение энергии (потока) излучения

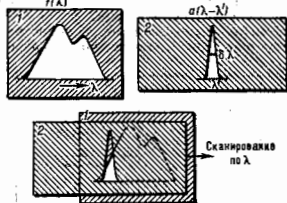


Рис. 1.

по длинам волн λ . Отверстие в экране 2 соответствует ф-ции $a(\lambda - \lambda')$, описывающей способность С. п. выделять из светового потока узкие интервалы $\Delta\lambda$ в окрестности каждой λ' . Эту важнейшую характеристику С. п. называют функцией пропускания или аппаратной функцией (АФ). Процесс измерения спектра $f(\lambda)$ прибором $a(\lambda - \lambda')$ можно имитировать, если поместить за экраном I приемник излучения и регистрировать изменения потока излучения, проходящего через остающиеся отверстия при наложении и перемещении (сканировании) экрана 2 по экрану I. Результат регистрации будет представлять собой нек-рую ф-цию времени $F(t)$, от к-рой, зная закон сканирования $\lambda'(t)$, легко перейти к ф-ции длины волн $F(\lambda)$, описывающей форму $f(\lambda)$ с той лучшей точностью, чем меньше была ширина АФ — интервал $\Delta\lambda$. Рассмотренный процесс математически описывается интегралом $F(\lambda') =$

$= j\alpha(\lambda - \lambda')/d\lambda$, называемым свёрткой ф-ции f с ф-цией λ . Ширина АФ наряду с рабочим диапазоном для волн является осн. характеристикой оптич. части С. п., она определяет спектральное разрешение $\delta\lambda$ и разрешающую способность $R = \lambda/\delta\lambda$. Чем шире АФ, тем меньше R , но тем больше поток излучения, пропускаемый прибором, т. е. больше оптич. сигнал, несущий измеряемую информацию, и больше отношение сигнал/шум M . Шумы, в свою очередь, зависят от полосы частот $\Delta\omega$ приёмно-усилит. системы прибора (обычно они пропорциональны $\sqrt{\Delta\omega}$). Чем меньше $\Delta\omega$, тем меньше шумы, но и тем больше инерционность системы и больше затраты времени t на измерения ($t \sim (\Delta\omega)^{-1}$). Взаимосвязь величин R , M , $\Delta\omega$ характеризуется инвариантом вида:

$$R^2 M(\Delta\omega)^2 = K(\lambda). \quad (1)$$

Показатели степени α и β принимаю разл. положит. значения в зависимости от конкретного типа С. п. (обычно $\alpha > 1$, $\beta < 1$). Константа «качества» K , зависящая только от λ , определяется конструктивными параметрами данного С. п. и накладывает ограничения на рабочие диапазоны значений R , M , $\Delta\omega$. Верх. предел R (мин. ширина АФ) нередко определяется аберрациями оптич. систем, дифракцией света, а макс. полоса $\Delta\omega$ лимитируется постоянной времени t приёмника излучения (или др. электр. явлений), т. к. $\Delta\omega \sim t^{-1}$.

Пролонгированный с помощью имитатора принцип действия С. п. относится к одноканальным методам спектрометрии. В распространённых наряду с ними многоканальных методах сканирование не применяется и потоки разных λ регистрируются одновременно. В имитаторе этому соответствует наложение на экран I другого неподвижного экрана, имеющего N отверстий для разных λ со своими АФ; при этом поток от каждого отверстия (накала) регистрируется независимо.

Общая классификация методов спектрометрии, являющихся основой разл. схем и конструкций С. п., осуществляется по двум осн. признакам — числу каналов и способам разделения λ (рис. 2).

Исторически первыми и наиб. распространёнными являются методы пространственного разделения λ

(спектрально-селективной фильтрации), к-рые даны классическими (группы 1 и 2). В одноканальной С. п. группы 1 исследуемый поток со спектром $f(\lambda)$ послысается на спектрально-селективный фильтр, к-рый выделяет из потока нек-рые интервалы $\delta\lambda$ в окрестности каждой λ' и может перестраиваться (непрерывно или дискретно), осуществляя сканирование спектра во времени t по неко-рому закону $\lambda'(t)$. Выделенные компоненты $\delta\lambda$ послысются на приёмник оптического излучения, запись сигналов к-рого даёт ф-цию времени $F(t)$. Переход от аргумента t к аргументу λ позволяет получить ф-цию $F(\lambda)$ — наблюдаемый спектр.

В многоканальных С. п. группы 2 одновременно регистрируются (без сканирования по λ) неск. приёмниками потоки излучения разных длин волн λ' , λ'' , λ''' , ..., к-рые выделяют, напр., многоэлементным монохроматором (полихроматором). Если расстояние между каналами не превышает $\delta\lambda$ и число каналов N достаточно велико, то получаемая информация аналогична содержащейся в записи на сканирующем одноканальном приборе (при тех же $\delta\lambda$, одинаковых приёмниках и пр. равных условиях), но время измерения может быть сокращено в N раз. Наиб. многоканальность достигается применением многоэлементных фотоэлектрич. приёмников излучения и фотогр. материалов (в спектрографах).

Для С. п. групп 3 и 4, получивших развитие с сер. 1980-х гг., принципиальной основой является спектрально-селективная модуляция (см. Модуляция света), при к-рой задача разделения длин волн λ переносится из оптич. части прибора в электрическую. В одноканальной С. п. группы 3 исследуемый поток со спектром $f(\lambda)$ послысается на устройство, способное модулировать нек-рой частотой $\omega_0 = \text{const}$ лишь интервал $\delta\lambda$ в окрестности длины волны настройки λ' , оставляя остальной поток немодулированным. Сканирование $\lambda'(t)$ проводится так, чтобы различные λ' последовательно модулировались частотой ω_0 . Выделяя составляющую ω_0 в сигнале приёмника с помощью электр. фильтра, получают ф-цию времени $F(t)$ и соответственно спектр $F(\lambda)$.

Многоканальные системы группы 4 основаны на операции мультиплексирования — одновременно приём излучения от многих спектральных элементов $\delta\lambda$ в кодированной форме одним приёмником. Это обеспечивается тем, что длины волн λ' , λ'' , λ''' , ... одновременно модулируются разл. частотами ω' , ω'' , ω''' , ... и суперпозиция соответствующих потоков в приёмнике излучения даёт сложный сигнал, частотный спектр к-рого по ω несёт информацию об исследуемом спектре по λ .

За рамками приведённой классификации остаются лишь методы т. н. активной спектрометрии, основанной на генерации излучения пререазируемыми по λ лазерами (см. Активная лазерная спектроскопия).

1. Одноканальные спектральные приборы с пространственным разделением волн

Основой оптич. схем С. п. этой группы является диспергирующий элемент (дифракционная решётка, шелец, шелец, интерферометр Фабри — Перо, спектральная призма), обладающий углом дисперсии $\Delta\varphi/\Delta\lambda$, что позволяет развернуть в фокальной плоскости изображения входной щели в излучении разных λ (рис. 3). Для объективов O_1 и O_2 обычно используются зеркала, не обладающие хроматич. аберрациями (в отличие от линзовых систем). Если в фокальной плоскости установлена одна выходная щель, схема С. п. представляет собой схему монохроматора, если неск. щелей — полихроматора, если фотоувеличит. слой или глаз — спектрографа или спектроскопа.

Одноканальные С. п. обычно строятся на основе монохроматора, в к-рых сканирование осуществляется поворотом дифракц. решётки. В простейших монохроматорах вместо диспергирующего элемента и выходной щели применяются циркулярно-клиновые интерференц.



Рис. 2. Классификация методов спектрометрии по числу каналов и способам разделения длин волн. Контуры шириной $\delta\lambda$ символизируют изображения аппаратной функции (АФ). В одноканальных методах (1 и 3) применяется сканирование (символ \rightarrow), в многоканальных (2 и 4) — сканирование отсутствует и всемерное интенсивности излучения ряда длин волн λ' , λ'' , λ''' , ... проводится одновременно.

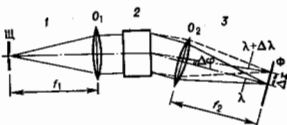


Fig. 3. Схема спектрального прибора с пространственным разделением анал. волн с помощью угловой дисперсии: 1 — входная щель; 2 — диспергирующий элемент, обладающий угловой дисперсией $\Delta\phi/\Delta\lambda$; 3 — Фокусирующая система (лазера) с объективом O_2 , содержащим в фокальной плоскости Φ изображение входной щели в направлении разных длин волн с линейной дисперсией $\Delta\lambda/\Delta\lambda$.

светофильтры с непрерывной перестройкой по λ полосы пропускания. Для таких С. п. характерно последовательное соединение функциональных элементов, в к-рых информативный сигнал к-л. образом обрабатывается (рис. 4). Для измерений спектров пропускания и отражения разл. образцов используются встроенные источники излучения со *слабыми спектром*, для исследований спектров внеш. излучателей — соответствующие осветители, а для непосредств. измерения поглощения в веществе могут использоваться оптико-акустич. ячейки,



Fig. 4. Блок-схема однолучевого однонаправленного прибора: И — источник излучения; Ф — оптический модулятор (объектор); Д — сканирующий фильтр (монокроматор); П — фотоэлектрический приёмник излучения; У — усилитель с преобразователем сигналов прибора; Р — выходящий или цифровой регистратор; БУ — блоки управления и обработки данных на базе ЭВМ.

преобразующие поглощённую энергию в подходящий для регистрации сигнал. В классич. С. п. оптич. модулятор вводится в схему лишь для того, чтобы в электр. части применить усиление на перем. токе.

Устройства управления С. п. и обработки результатов измерений строятся на базе микропроцессоров. Они отличаются большим разнообразием и обеспечивают оптимизацию режимов работы С. п. по параметрам R , M , $\Delta\omega$ в рамках условия (1) [для классич. С. п. условие имеет вид $R^2 M^2 \Delta\omega = K(\lambda)$, если шум приёмника не зависит от падающего на него потока]. Вместо величины K иногда используют т. н. энергетический фактор $Q(\lambda) = M^2 \Delta\omega / (\delta\lambda)^2 = \lambda^2 K(\lambda)$, к-рый численно равен отношению сигнал/шум, наблюдаемому при единичном выделяемом спектральном интервале $\delta\lambda$ и единичной полосе частот $\Delta\omega$. Накладываемые факторы Q энергетич. ограничения играют осн. роль в ИК-области, где яркости источников быстро уменьшаются и значения Q малы; напр., в ср. ИК-области (≈ 10 мкм) хорошие С. п. имеют $Q = 10^6 \text{ мкм}^{-2} \text{ Гц}^{1/2}$ (в шкале волновых чисел $Q = 10^6 \text{ см}^{-2} \text{ Гц}^{1/2}$). В видимой и ближней ИК-области энергетич. ограничения играют меньшую роль и рабочие значения R могут приближаться к дифракц. пределу (напр., в С. п. с дифракц. решётками — к значению $R_{\text{диф}} = 2kV \text{ Lsin}\phi$, где k — кратность дифракции, $v = 1/\lambda$ — волновое число, L — ширина решётки, ϕ — угол дифракции).

Рассмотрим типичные приборы группы 1.

Спектрометры высокого разрешения для исследовательской структуры атомных и молекулярных спектров представляют собой стационарные лаб. установки, построенные по схеме рис. 4. В зависимости от области спектра применяются разнообразные монокроматоры (с фокусными расстояниями до 10 м) в вакуумных корпусах, в виброзащитённых и термостабилизиров. помещениях. В этих приборах используются 2- и 4-кратная дифракция на шёлках шпривой до 400 мк, применяются спец. источники и охлаждаемые приёмники, что позволяет достигать в спектрах поглощения $R \approx 2 \cdot 10^6$ в области длин волн 2,5 мкм. Для выявления ещё более тонкой структуры в схему измерений вводят сканирующие интерферометры Фабри — Перо ($R \approx 10^6$ в видимой области).

Спектрофотометры (СФ) выполняют операции фотометрирования для определения отношений потоков — безразмерных коэф. пропускания и отражения разнообразных образцов веществ и материалов. В наиб. прецизионных СФ эта задача решается по схеме рис. 4 сравнением двух последоват. отсчётов для одного и того же пучка излучения: «образец в пучке», «образец вне пучка». Такой же метод применяется в массовых нерегистрирующих СФ — сравнительно дешёвых С. п., соти разнообразностей к-рых выпускаются десятками фирм. Серийные автоматич. регистрирующие СФ основаны на более сложных, но и более производительных двухлучевых схемах измерений, отличающихся от однолучевой тем, что между источником и фильтром (или между фильтром и приёмником) организованы два пучка излучения — измерительный (в к-рый помещается образец) и референтный. Эти пучки модулируются по определ. алгоритмам, обеспечивающим работу т. н. систем электрического отношения, регистрирующих коэф. пропускания T или оптич. плотности $D = -\lg T$ ($0 \leq T \leq 1$) как ф-ции λ или $v = 1/\lambda$. Использовавшиеся для этих целей системы оптич. нуля практически вышли из употребления к ок. 1980-х гг.

Многочисл. модели автоматич. СФ можно разделить примерно на три класса: сложные универсальные СФ для науч. исследований ($R \sim 2000$ –5000), приборы ср. класса ($R \sim 500$ –4000) и простые, т. н. рутинные, СФ ($R \sim 100$ –500) с рабочими спектральными диапазонами, заполняющими всю область прозрачности атмосферы 0,19–50 мкм. Кроме того, спец. вакуумные модели выпускаются для УФ-области (0,1–0,2 мкм) и ИК-области (50–300 мкм). Конструкции автоматич. СФ обеспечивают широкий выбор значений R , M , $\Delta\omega$, скорости и масштабов регистрации спектров разл. объектов, приборы оснащаются наборами газовых и жидкостных кювет, приставками для измерений зеркального и диффузного отражений, а также нарушенного полного внутреннего отражения, приставками для измерений малых образцов, для исследований при разных темп-рах и т. п. В конструкции спец. типов СФ вводят микроскопы (микроспектрофотометры), устройства для исследований спектров люминесценции (спектрофлуориметры), дисперсии показатели преломления (спектрорефрактометры), поляризации (спектрополяриметры), измерений яркости внеш. излучателя в сравнении с встроенным эталонным (спектрорадиометры), испытаний чувствительности фотоматериалов (спектросенситометры) и др.

Автоматич. СФ являются осн. приборами для исследовательской спектральной характеристики веществ и материалов и абсорбционного спектрального анализа.

Спектрометры комбинационного рассеяния могут быть однолучевыми и двухлучевыми. Источниками излучения в них обычно служат лазеры, а для наблюдения комбинац. частот (см. Комбинационное рассеяние света) и подавления фона, создаваемого первичным излучением, применяются двойные и тройные монокроматоры с голографич. дифракц. решётками. В лучших приборах отношение фона к полезному сигналу снижено до

10^{-13} и комбинац. частоты могут наблюдаться на расстояниях порядка десят. см⁻¹ от возбуждающей линии.

Скоростные спектрометры (хроспектрометры) работают по схеме рис. 4, но в отличие от др. С. п. их снабжают устройствами быстрого цикла, сканирования и широкополосными ($\Delta\omega$ до 10^7 Гц) приёмно-регистрирующими системами. Для исследований кинетики хим. реакций сканирование ведётся с малой скважностью, к-рая достигается, напр., методом бегущей щели: вместо выходной щели в фокальной плоскости устанавливается быстро вращающийся диск с большим числом радиальных прорезов. Таким способом получают до 10^4 спектров в 1 с. Если время жизни объекта слишком мало, применяют более быстрое сканирование вращающимися зеркалами, это приводит к большой скважности и требует синхронизации начала процесса с моментом прохождения спектра по щели.

2. Многоканальные спектральные приборы с пространственным разделением длин волн

В этой группе приборов сканирование не применяется, дискретный ряд длин волн (в полихроматорах) или участки непрерывного спектра (в спектрографах) регистрируются одновременно и оптич. часть строится обычно по схеме, приведённой на рис. 3. Если вместо системы, создающей угл. дисперсию, служит набор узкополосных светофильтров, то прибор относят к **фотометрам**.

Многоканальные приборы используются гл. обр. для спектрального анализа элементного состава по аналитич. спектральным линиям. По мере увеличения числа каналов появляется возможность изучения спектральных распределений $f(\lambda)$. Рассмотрим наиб. типичные приборы этой группы (в порядке возрастания числа каналов).

Пламенные (атомно-абсорбционные и эмиссионные) спектрофотометры имеют обычно 1–2 канала регистрации. Они измеряют интенсивности линий абсорбции, эмиссии или флуоресценции атомов элементов в пламени спец. горелок или др. атомизаторов. В простых конструкциях аналитич. линии выделяются узкополосными фильтрами (пламенные фотометры), в приборах более высокого класса применяются полихроматоры или монохроматоры, последовательно переключаемые на разл. длины волн λ . Приборы данного типа используются для определения большинства элементов периодич. системы. Они обеспечивают высокую избирательность и чувствительность (до 10^{-14} г).

Квантометры — фотоэлектрич. установки для промышленного спектрального анализа сталей, сплавов, смазочных масел, минералов — строятся на основе полихроматоров; выходные щели полихроматора выделяют из спектра излучения исследуемого вещества аналитич. линии и линии сравнения; соответствующие световые потоки посылаются на приёмники (фотоумножители), уставовленные у каждой щели. Фотоны приёмников заряжают накопит. конденсаторы; величина заряда, накопленного за время экспозиции, служит мерой интенсивности линии, к-рая пропорциональна концентрации элемента в пробе. Модели квантометров различаются рабочими диапазонами спектра (внутри области $0,17$ – 1 мкм), числом одновременно работающих каналов (от 2 до 80), степенью автоматизации, способами возбуждения спектров (дуга, искра, лазер, источник на основе индуктивно-связанной плазмы).

Спектрографы одновременно регистрируют протяжённые участки спектра, развёрнутого в фокальной плоскости (рис. 3), на фотопластинах и фотоплёнках (фотог. спектрографы), а также на экранах электроно-оптич. преобразователей с «эвадоминантным» изображением. Типы спектрографов отличаются большим разнообразием — от простых приборов настольного типа для учебных целей и компактных ракетных и спутниковых бортовых спектрографов до крупных астроцентриграфов, работающих в обсерваториях в сочетании с телескопами, и лабораторных 10-метровых вакуумных уста-

новок с большими дифракц. решётками для исследования *тонкой структуры* спектров. Линейная дисперсия спектрографов $\Delta\lambda/\Delta\lambda$ может лежать в пределах 10^4 – 10^6 мм/мкм, разрешающая способность — достигать дифракц. предела, световая сила по освещённости (отношение освещённости в изображении входной щели к яркости источника, освещающего входную щель) — от 0,5 в светосильных приборах до 10^{-3} и менее в длиннофокусных приборах большой дисперсии.

Развитие многоэлементных приёмников матричного типа (с числом элементов до 1024) открыло возможность анализа излучений по спектральной и пространственной координатам и привело к появлению разл. вариантов фотоэлектрич. спектрографов-спектрометров с системами электронного сканирования (последоват. опроса сигналов приёмных элементов). Такие С. п., строго говоря, не являются многоканальными, поскольку в них отсутствует независимый и одноврем. регистрация сигналов от каждого приёмного элемента.

Скоростные многоканальные С. п. для исследований спектров быстротекущих процессов конструируются путём сочетания спектрографа со скоростной кинокамерой (киносектрографы), введения в схему прибора многогранных вращающихся зеркал, применения многоканальной регистрации с многоэлементными приёмниками (такие С. п. наз. хроспектрографами, спектрохронографами, спектровизорами).

3. Одноканальные спектральные приборы со спектрально-селективной модуляцией

Типичными приборами 3-й группы являются растровые спектрометры и сисамы.

Растровые спектрометры строятся по общей схеме, представленной на рис. 4, но в сканирующем фильтре (монохроматоре) входная и выходная щели заменяются идентичными *растрами*. При периодич. сдвиге одного из растров с нек-рой частотой ω_0 возникает амплитудная модуляция тол λ' , для к-рой изображение входного растра совпадает с выходным растром. Для других λ изображения смещаются в результате угл. дисперсии и амплитуда модуляции уменьшается. Ширина АФ бл такого С. п. соответствует волномеру растра. По сравнению со щелевыми растровые монохроматоры дают значит. выигрыш в потоке, однако их применение ограничено засветкой приёмника большим потоком немодулиров. излучения, сложностью изготовления растров и высокими требованиями к качеству оптики. На растровой установке уникального типа с фокусным расстоянием 6,5 м достигались значения $R = 2 \cdot 10^5$ в области 2,5 мкм.

Сисамы — спектрометр интерференционный с селективной амплитудной модуляцией — строятся на основе двухлучевого интерферометра (рис. 5), в к-ром зер-

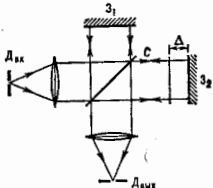


Рис. 5. Принципиальная оптическая схема двухлучевого сканирующего интерферометра. А_{вх}, А_{вых} — входная и выходная круглые дифракции; С — светоделительная щель; 3 — вращающееся зеркало; 4 — подвижное зеркало, перемещаемое (сканируемое) на расстояние Δ (разность хода).

кала заменены синхронно поворачивающимися дифракц. решётками и введён модулятор по оптич. разности хода. В этом случае амплитудная модуляция накладывается только на интервал $\Delta\lambda_{\text{эф}}$, соответствующий дифракц. пределу вблизи λ , к-рая удовлетворяет условию максимума дифракции для обеих решёток. Сисам всегда работает на дифракц. пределе: $R = \lambda/\Delta\lambda_{\text{эф}}$, при этом за счёт увеличения входного отверстия поток при-

мерно в 100 раз больше, чем в классич. приборах 1-й группы, но оптико-механич. часть весьма сложна в изготовлении и настройке. С помощью сисема достигнута наивысшая разрешающая способность с дифракц. решётками в ср. ИК-области: $R = 1 \cdot 10^3$ (в диапазоне 8—10 мкм при точности определения длин волн 10%).

4. Многоканальные спектральные приборы со спектрально-селективной модуляцией

Для данной группы С. п. характерны одноврем. спектрально-селективная модуляция (кодирование) длин волн, восприимчивых одним фотоэлектрич. приёмником, и последующее декодирование электр. сигналов. Наиб. распространение получили два типа приборов этой группы — адамар-спектрометры и фурье-спектрометры.

Адамар-спектрометры строятся по схеме спектрографа с дифракц. решёткой (рис. 3). Разл. длины волн развёрнутого в фоновальной плоскости спектра одновременно кодируются циклически сменяемыми масками-матрицами Адамара и посылаются на фотоэлектрич. приёмник, сигналы к-рого декодируются вычислит. устройством по регистрируются в виде дискретного спектра. Такой метод продлевает рабочий диапазон спектрографов в ИК-область и позволяет решать широкий круг задач молекулярного спектрального анализа — от определения состава выхлопных газов двигателей переносными приборами до анализа веществ с высоким разрешением на уникальных установках (R до $1,7 \cdot 10^4$ в области 6 мкм).

Фурье-спектрометры осуществляют непрерывное кодирование длин волн с помощью интерференц. модуляции, реализуемой обычно по схеме рис. 5, представляющей собой двухлучевой интерферометр Майкельсона. При равномерном перемещении зеркала Z_2 в интерференц. картине на выходной диафрагме возникает от каждой монохроматич. составляющей λ входящего излучения периодич. мерцание (светло — темно) с частотой тем большей, чем меньше λ . Суперпозиция таких модулируя. вкладов от всех поступающих λ в приёмнике регистрируется в ф-ции *разности хода* Δ , образуя и интерферограмму $I(\Delta)$, фурье-преобразование к-рой на востроенной ЭВМ даёт спектр $F(\nu)$. Фурье-спектрометры одновременно реализуют два выигрыша: за счёт многоканальности и за счёт увеличения входного отверстия. Они наиб. эффективны для исследований протяжённых спектров слабых излучений (особенно в ИК-области, где требования к оптич. интерферометру упрощаются). Конструкция и характеристики приборов этого типа весьма разнообразны: от лаб. спектрометров универсального типа, выпускаемых серийно многими фирмами, до компактных спутниковых (для геофиз. и космич. исследований) и уникальных стационарных установок с разностью хода до 10 м, на к-рых достигаются точность измерений λ и разрешающая способность на порядок выше, чем в классич. С. п. (напр., R до $3 \cdot 10^8$ в ближней

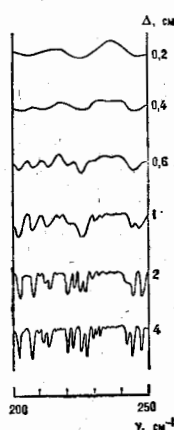


Рис. 6. ИК-спектры поглощения паров воды на участке 200—250 см⁻¹, полученные с помощью фурье-спектрометра при различных оптичных разностях хода Δ в интерферометре. Чем больше Δ , тем больше деталей можно вывить в исследуемом участке спектра, так как тем больше разрешающая способность $R = \lambda/\delta\lambda = \nu/\delta\nu = \nu/\Delta$.

ИК-области). (Подробнее см. в ст. *Фурье-спектрометр*.)

Итак, принципиальное различие рассмотренных групп приборов следующее: в одноканальных С. п. группы 1 и 3 время эксперимента затрачивается на накопление информации о новых участках спектра (на сканирование по λ), в многоканальных приборах группы 2 — на накопление сигнала и усреднение шумов (улучшение отношения сигнал/шум), а в фурье-спектрометрах — на накопление структурных деталей в данном спектральном диапазоне (рис. 6).

Лит.: Тарасов К. И., Спектральные приборы, 2 изд., Л., 1977; Пейсаков И. В., Оптика спектральных приборов, 2 изд., Л., 1975; Зайделя А. И., Островский А. Р., Островский Э. И., Техника и практика спектроскопии, 2 изд., М., 1978; Инфракрасная спектроскопия высокого разрешения, пер. с франц. и англ., М., 1972; Велл Р. Д. и др., Введение в фурье-спектроскопию, пер. с англ., М., 1975; Мелышев В. И., Введение в экспериментальную спектроскопию, М., 1979; Мибери Д. и др., Обнаружение и спектрометрия слабых источников света, пер. с англ., М., 1979; Нагайбьян И. М., Михалюковский Ю. К., Фотографические и фотоэлектрические спектральные приборы в длинноволновой области, М., 1981; Новые методы спектроскопии, Новосиб., 1982; Современные тенденции в технике спектроскопии, под ред. Г. Н. Раутова, Новосиб., 1982; Сидорова И. В., Оптичные спектральные приборы, М., 1984; Гершуль М. А., Бетрова Л. В., Спектрометры с селективной интерференцией, «Оптико-мех. пром.» 1987, № 4, с. 47; Свето-сильные спектральные приборы. Сб., под ред. К. И. Тарасова, М., 1988; Приборы спектральной оптики. Термины и определения. ГОСТ 27178—88. В. А. Никитин.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ (дисперсионные призмы)

— одна из групп *призм оптичных*; служат для пространственного разделения (разложения в спектр) излучений оптич. диапазона на монохроматич. составляющие, различающиеся длинами волн. Разделение лучей на монохроматич. составляющие является результатом зависимости угла отклонения θ луча прошедшего через призму (рис. 1), от показателя преломления материала призмы n , различный для разных длин

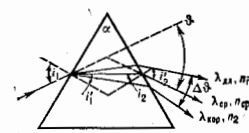


Рис. 1. Ход лучей в простой трёхгранной призме.

волн λ (см. *Дисперсия света*). Качество призмы характеризуется угл. дисперсией $\Delta\theta/\Delta\lambda$, к-рая зависит от материала призмы (волочил n и $\Delta n/\Delta\lambda$), преломляющего угла α и угла падения i_1 (а следовательно, и от углов преломления i_1' и i_2' на первой и второй гранях призмы):

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{\sin \alpha}{\sin i_1 \cos i_2'} \cdot \frac{\Delta n}{\Delta \lambda}$$

Для изготовления призм используют материалы с большой дисперсией, прозрачные в исследуемой области спектра, с высокой оптич. однородностью и изотропностью. В зависимости от исследуемой области спектра применяются С. п.: на стекла (чаще всего флинта) — для видимой области; кристаллич. кварца, флюорита и др. — для УФ-области; фтористого лития, хлористого магния и др. — для ИК-области.

Существует неск. видов наиб. употребительных С. п.

1. Простая трёхгранная призма (рис. 1) используется как самостоят. диспергирующий элемент в спектральных приборах, а также является осн. составной частью всех более сложных призматич. систем. В спектральном приборе призма устанавливают так, чтобы линия пересечения её преломляющих граней (преломляющее ребро) была параллельна входной щели. Двугранный угол α , образованный рабочими гранями призмы, наз. *преломляющим углом*.

Обычно он равен 60° . Угол отклонения луча после преломления призм: $\theta = i_1 + i_2 - \alpha$. Условие симметричного хода лучей через призму $i_1 = i_2$ и $i_1' = i_2' = \alpha/2$. Углы протяжённости участка спектра от коротковолновой ($n_{кор}$, n_1) до длинноволновой границы ($n_{дл}$, n_2):

$$\Delta\theta = (n_1 - n_2)2\sin(\alpha/2) / \sqrt{1 - \frac{n^2}{c^2} \sin^2(\alpha/2)},$$

где $n_{ср} = (n_1 + n_2)/2$.

При увеличении угла α и показателя преломления n угол отклонения луча θ увеличивается до предельного значения, при котором наступает полное внутр. отражение на второй грани призмы и луч из призмы не выходит. Обычно призму устанавливают в положение мин. отклонения, что обеспечивает получение макс. разрешающей способности, отсутствие астигматизма и угл. увеличения. Для данных α и n при симметричном ходе лучей в призме угол отклонения θ мин. значение принимает при условии:

$$\theta_{мин} = 2 \arcsin [n \sin(\alpha/2)] - \alpha,$$

т. е. для разл. длин волн мин. отклонение происходит при разл. положениях призмы по отношению к падающему пучку лучей.

Разноудельность простой трёхгранной призмы является призмам Корню (рис. 2, а), представляющая собой соединение на оптическом контакте двух

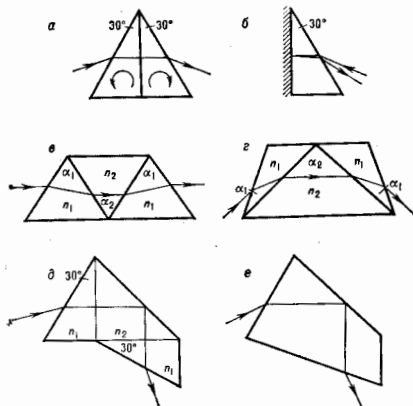


Рис. 2. Спектральные призмы: а — призма Корню; б — призма Литрова; в — призма Амичи; г — призма Розерфорда — Броунинга; д — призма Аббе (составная); е — призма Аббе (из одного куска).

прямоуг. призм с преломляющим углом 30° , вырезанных из лево- и правовращающего кварца с общим направлением оптич. оси параллельно основаниям призм (см. *Оптическая активация, Оптические активные вещества*). В результате после прохождения луча через лево- и правовращающие части призмы *вращение плоскости поляризации* оказывается скомпенсированным и, следовательно, *двойное лучепреломление* отсутствует, что улучшает качество изображения спектральных линий. В автоколлимацион. приборах (см. *Автоколлимация*) того же эффекта достигают, применяя

одну пополамную призму Корню, большой кат-кроем покрыт отражающим слоем (призму Литтрова, рис. 2, б). Дисперсия такой призмы равна дисперсии одной призмы с $\alpha = 60^\circ$, установленной в положение мин. отклонения.

2. Призма Розерфорда — Броунинга (рис. 2, г) состоит из трёх частей. Между двумя одинаковыми призмами с небольшим преломляющим углом α_1 ($\sim 25^\circ$), изготовленными из стекла с малым показателем преломления и малой дисперсией (кrown), находится призма с большим преломляющим углом α_2 (100°), изготовленная из стекла с большим показателем преломления и с большой дисперсией (флинт). Все три призмы склеены между собой либо соединены на оптич. контакт. Назначения боковых призм — уменьшить потери на отражение за счёт уменьшения угла падения на первую грань. Призма Розерфорда — Броунинга выгодно отличается от одиночной призмы большей дисперсией (в 1,5–2 раза), а при заданной дисперсии — меньшими потерями на отражение. Но при той же ширине пучка излучения длина хода лучей в этой призме больше, чем в одиночной, и её применение малоэффективно в УФ-области спектра, где поглощение в тяжёлых флинтах заметно возрастает.

3. Призма прямого зрения (призма Амичи) состоит из трёх или более трёхгранных призм (рис. 2, в) и обладает тем свойством, что для нек-рой длины волны угол отклонения лучей равен нулю. Ср. призма изготавливается из флинта, две боковые из crown. При заданных значениях показателей преломления призм n_1 и n_2 для данной длины волны имеет место такое соотношение между углами призм α_1 и α_2 , при котором угол отклонения для всех систем $\theta = 0$; благодаря этому в приборах с призмой Амичи оптическая ось не имеет излома. При этом излучение более коротких длин волн отклоняется в сторону основания ср. призмы, а более длинноволновое — в сторону её вершины. Призма Амичи не даёт столь высокой дисперсии, как призма Розерфорда — Броунинга, а из-за длинного хода лучей в призме Амичи поглощается больше лучистой энергии, чем в одиночной призме. Поэтому призмы прямого зрения получили ограниченное распространение. Их используют в спектроскопах и спектрографах малой дисперсии, когда совпадение осей объективов камеры и коллиматора позволяет разместить детали прибора в прямой трубе.

4. Призма Аббе (рис. 2, д) — призма постоянного угла отклонения, состоит из двух 30° -градусных прямоуг. призм, приклеенных к катетным граням равнобедренной прямоуг. призмы, из того же материала ($n_1 = n_2$). Поэтому равнобедренная прямоуг. призма на дисперсию влияния не оказывает, выполняет роль зеркала и эквивалентна плоскопараллельной пластине. Дисперсия света в призме Аббе происходит лишь на гранях полупризм. При условии мин. отклонения углы входа лучей в призму Аббе и выхода из неё равны по абс. величине и противоположны по знаку. Поэтому луч, проходящий через призму Аббе в минимуме отклонения, покидает её, образуя независимо от длины волны прямой угол с лучом, входящим в призму. Вращая призму вокруг нек-рой вертикальной оси, можно привести к условию мин. отклонения лучи разл. длин волн. По угл. дисперсии и потерям на отражение эта система эквивалентна одиночной призме с преломляющим углом 60° . Чтобы избежать склеивания отд. частей, призму Аббе иногда делают в виде целого стеклянного блока из одного материала (рис. 2, е). При работе в УФ-области вместо призмы полного внутр. отражения используют зеркало.

5. Призма Ферри наряду с разложением в спектр пучка лучей обеспечивает и их фокусировку. Это достигается в результате того, что рабочие грани призмы искривлены и одна из них с нанесённым на неё металлик. покрытием является зеркалом. При радиусе кривизны выходной поверхности R спектр

располагается на окружности радиуса 0,5 R. Однако призма Ферри обладает значит. астигматизмом и может применяться только в приборах с малой апертурой.

До 1970-х гг. С. п. широко применялись в спектральных приборах разл. типов. В 1970—80-х гг. सर्वыми конструкторами С. п. стали дифракционные решетки. Однако С. п. продолжают использоваться в простых спектральных приборах, предприт. монохроматорах, а также в качестве разделителей порядков в приборах с решетками. Призмы также с успехом используются в качестве селекторов в резонаторах твердотельных и жидкостных лазеров.

Лит.: П е я с а х о н И. В., Оптика спектральных приборов, 2 изд., Л., 1975; Л е б е д е в а В. В., Техника оптической спектроскопии, 2 изд., М., 1986; М а д и м с е в В. И., Введение в экспериментальную спектроскопию, М., 1970; С к о п о в И. В., Оптические спектральные приборы, М., 1984. Л. Н. Каптерев, СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — совокупность методов определения элементного и молекулярного состава и строения веществ по их спектрам. С помощью С. а. определяют как осн. компоненты, составляющие 50—60% вещества анализируемых объектов, так и незначит. примеси в них (до 10^{-3} — 10^{-8} и менее). С. а. — наиб. распространенный аналитич. метод, св. 20—30% всех анализов выполняется с помощью этого метода, в т. ч. контроль состава сплавов в металлургии, автомоб. и авиац. пром-сти, технологии переработки руд, анализа экологич. объектов и материалов высокой чистоты, хим., биол. и мед. исследования. Особое значение С. а. имеют при поисках полезных ископаемых.

Основа С. а. — спектроскопия атомов и молекул; его классифицируют по целям анализа и типам спектров. В атомном С. а. (АСА) определяют элементный состав образцов по атомым (ионным) спектрам испускания и поглощения; в молекулярном С. а. (МСА) — молекулярный состав вещества по молекулярным спектрам поглощения, испускания, отражения, люминесценции и комбинационного рассеяния света. Э м и с с и о н н ы й С. а. проводят по спектрам испускания возбужденных атомов, ионов и молекул. А б с о р б ц и о н н ы й С. а. осуществляют по спектрам поглощения анализируемых объектов. В С. а. часто сочетают нек. спектральных методов, а также применяют др. аналитич. методы, что расширяет возможности анализа. Для получения спектров используют разл. типы спектральных приборов в зависимости от целей и условий анализа. Обработка эксперим. данных может производиться на ЭВМ, встроенных в спектральный прибор.

Атомный спектральный анализ

Различают два осн. варианта атомного С. а. — атомно-эмиссионный (АЭСА) и атомно-абсорбционный (ААА).

Атомно-эмиссионный спектральный анализ основан на зависимости $I = f(c)$ интенсивности I спектральной линии испускания (эмиссии) определяемого элемента z от его концентрации в анализируемом объекте:

$$I_z = \frac{1}{4\pi} A_{qp} n_q n_p^{\nu} q_p, \quad (1)$$

где A_{qp} — вероятность квантового перехода из состояния q в состояние p , n_q — концентрация атомов, находящихся в состоянии q в источнике излучения (исследуемом веществе), ν_{qp} — частота квантового перехода.

Если в зоне излучения выполняется локальное термодинамическое равновесие, концентрация электронов $n_e > 10^{14}$ — 10^{16} и их распределение по скоростям максвелловское, то

$$n_q = n_0 \frac{g_q}{Z} \exp(-\theta_q/kT), \quad (2)$$

где n_0 — концентрация невозбужденных атомов определяемого элемента в области излучения, g_q — статистический вес состояния q , Z — статистическая

сумма по состояниям q , $Z = \sum_q g_q \exp(-\theta_q/kT)$.

θ_q — энергия возбуждения уровня q . Т. о., искомая концентрация n_q — ф-ция темп-ры, к-рая практически не может строго контролироваться. Поэтому обычно измеряют интенсивность аналитич. линии относительно нек-рого внутр. стандарта, присутствующего в анализируемом объекте в известной концентрации $n_{ст}$. Если стандартная линия близка к аналитической, то $I_z/I_{ст} = K n_q (K$ — постоянная величина). Эта зависимость используется в С. а. в тех случаях, когда отсутствует самопоглощение исследуемых линий.

В АЭСА применяются в осн. спектральные приборы с фоторегистрацией (спектрографы) и фотоэлектрич. регистрации (квантометры). Излучение исследуемого образца направляется на входную щель прибора с помощью системы линз, попадает на диспергирующее устройство (призма или дифракц. решетка) и после монохроматизации фокусируется системой линз в фокальной плоскости, где располагается фотопластика или система выходных щелей (квантометр), за к-рыми установлены фотоземляки или фотомножители. При фоторегистрации интенсивности линий определяют по плотности почернения S , измеряемой микрофотометром:

$$S = \gamma \log I t p,$$

где p — т. н. константа Шварцшильда, γ — фактор контрастности; t — время экспозиции.

В АЭСА исследуемое вещество должно находиться в состоянии атомного газа. Обычно атомизация и возбуждение атомов осуществляются одновременно — в источниках света. Для анализа металлов, сплавов и др. проводников чаще всего используют дуговой разряд или искровой разряд, где в качестве электродов служат сами анализируемые пробы. Дуговой разряд применяется и для анализа непроводящих веществ. В этом случае порошкообразную пробу помещают в углубление в графитовом электроде (метод испарения) или с помощью дугового устройства вводят порошок в плазму дугового разряда между горизонтально расположенными графитовыми электродами. Применяется также введение порошкообразных проб в дуговые плазмотроны.

При АЭСА растворов в качестве источников возбуждающего света применяют пламя горючих газов (смеси ацетилеи — кислород, ацетилеи — закись азота и др.). В качестве источников света начали использовать также безэлектродный разряд и особенно индуктивно-связанную плазму. Во всех случаях растворов в виде аэрозоля потоком аргона вводят в зону возбуждения спектра (темп-ра 2500—3000 К в пламёнах и 6000—10000 К в плазме разряда), где происходит высушивание, испарение и атомизация аэрозоля.

Процесс атомизации в методах АЭСА обычно носит термич. характер, что позволяет сделать нек-рые обобщения. В реальных условиях, учитывающих кинетич. процессы, для частиц, находящихся в зоне с темп-рой $T > T_{кип}$ ($T_{кип}$ — темп-ра кипения), зависимость кол-ва испарившихся частиц от времени описывается ур-нием:

$$r^3 - r_0^3 = 6D\sigma p M^2 t (\beta T)^3,$$

где r — радиус частицы, D — коэф. диффузии, σ — поверхностное натяжение раствора, p — давление насыщенных паров, M — мол. масса, β — плотность. Пользуясь этим ур-нием, можно найти кол-во вещества, испарившегося за время t .

Если при этом молекула состоит из элементов n_1 и n_2 , то степень атомизации может быть рассчитана по ур-нию:

$$\frac{n_1}{n_{1,0} + n_1} = \frac{1,88 \cdot 10^{10}}{n_2} \cdot \frac{Z_1 Z_2}{Z_2} \left(\frac{M_1 M_2}{M_{\text{моля}}^2} \right)^{3/2} T^{3/2} \cdot \exp(-\theta/kT),$$

где M_1 и M_2 — ат. массы элементов λ_1 и λ_2 ; Z_1 и Z_2 — статистич. суммы по состояниям этих элементов, $M_{\text{мол}}$ — мол. масса атомизирующейся молекулы, Z_3 — статистич. сумма по её состояниям, ϵ — энергия диссоциации молекулы. Такого типа расчёты позволяют найти концентрацию атомов определяемого элемента λ_3 в ур-нии (2) и определить её связь с интенсивностью аналитич. линии. Необходимо учитывать взаимодействие определяемого элемента с окружающей средой, др. компонентами анализируемого вещества, ионизацию атомов определяемого элемента и др. эффекты значительно усложняют картину испарения и атомизации исследуемого вещества. С целью облегчения С. а. создаются спец. программы расчёта на ЭВМ достаточно сложных реакций в газовой и конденсированных фазах при заданных темп-ре и давления.

В источниках излучения чаще всего не соблюдается термодинамич. равновесие, поэтому эти расчёты могут использоваться лишь при выборе оптич. условий анализа. В АЗСА применяют эмпирич. метод, заключающийся в эксперим. построении аналитич. ф-ции $I_x/I_{\text{ср}} = f(c)$ с помощью серии стандартных образцов анализируемого материала с заранее точно известными содержаниями определяемого элемента. Такие образцы либо изготавливают специально, либо заранее в пресс. образцах устанавливают концентрацию этого элемента точными методами. Измеряя затем аналитич. сигнал $I_x/I_{\text{ср}}$, находят содержание определяемого элемента в пробе.

Структура и физ.-хим. свойства анализируемого и стандартного объектов могут оказаться неадекватными (различны, напр., условия паробразования степени атомизации, условий возбуждения). Эти различия приходится учитывать при С. а. В таких случаях используют метод факторного статистич. планирования эксперимента. В результате экспериментов получают т. н. ур-ния регрессии, учитывающие влияние на интенсивность аналитич. линий концентраций всех элементов, составляющих пробу, и устанавливают концентрацию анализируемого элемента с помощью этих ур-ний. Совр. многоканальные квантометры позволяют одновременно измерять интенсивность большого числа спектральных линий. На основе этих эксперим. данных с помощью ЭВМ можно решать довольно сложные случаи анализа, однако за счёт измерения неск. линий случайная погрешность определения С. возрастает.

Атомо-абсорбционный анализ (ААА) основан на зависимости аналитич. сигнала (абсорбционности) $A = \log I_0/I$, (где I_0 , I — интенсивности падающего и прошедшего сквозь образец света) от концентрации (Бугера — Ламберта — Бера закон):

$$A = \exp(-k \cdot l \cdot n),$$

где k — коэф. поглощения на частоте ν , l — эфф. длина светового пути в области поглощения, n — концентрация атомов анализируемого элемента в паре.

Схема установки ААА включает: независимый источник излучения света с частотой ν , равной частоте аналитич. линии определяемого элемента; атомизатор, преобразующий пробу в атомарный пар; спектрофотометр. Свет, прошедший сквозь атомарный пар, системой линз направляется на входную щель спектрофотометра, интенсивность аналитич. спектральной линии I_0 и I на выходе регистрируется фотоелектрич. методом. Поскольку естественная ширина спектральной линии постоянна, зависит только от времени жизни возбуждённого состояния и обычно пренебрежимо мала, разница контуров линии испускания и поглощения определяется в осн. доплеровским $\Delta\nu_D$ и лоренцевским $\Delta\nu_L$ уширениями:

$$\Delta\nu_D = \frac{2\nu_0}{c} \sqrt{2 \ln(2RT)/A},$$

$$\Delta\nu_L = K \sigma^2 p \sqrt{\frac{2}{\pi T} \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M} \right)}$$

(здесь p — давление, c — скорость света, t — атомная, M — молекулярная массы, σ^2 — эфф. сечение столкновений, приводящих к уширению, K — константа). Т. о., ширины контуров линий поглощения и испускания могут быть различными в зависимости от давления, темп-ры и состава газовой фазы в источнике излучения и в поглощающей ячейке, что отразится на виде ф-ции $A = f(c)$ и может привести к неоднозначности результатов С. а. До нек-рой степени это удаётся устранить достаточно сложными приёмами. В методе Уолла применяют лампы с полым катодом (ЛПК), к-рые излучают спектральные линии значительно более узкие, чем линии поглощения атомов определяемых элементов в обычных поглощающих ячейках. В результате зависимость $A = f(c)$ в довольно широких пределах значений A (0 — 0,3) оказывается простой линейной ф-цией.

В качестве атомизатора в ААА используют разл. плазмы на основе смесей водород — кислород, ацетилен — воздух, ацетилен — закись азота и др. Анализ подвергают аэрозоль раствора пробы, вдвухимый в горящее пламя. Последовательно измеряют интенсивности I_x и I_0 света, прошедшего сквозь пламя во время подачи аэрозоля и без его подачи. В совр. приборах измерение I_x и I_0 автоматизировано. В нек-рых случаях процессы испарения и последующей атомизации пробы из-за низкой темп-ры пламен ($T \sim 3000$ К) в газовой фазе происходят не полностью. Процессы испарения частиц аэрозоля и степень атомизации в пламени сильно зависят также от состава пламени (соотношения горючего и окислителя), а также от состава раствора аэрозоля. Хорошую воспроизводимость аналитич. сигнала (в лучших случаях S_r составляет 0,01—0,02) удаётся получить, применяя в качестве источников ЛПК, излучение к-рого обладает высокой стабильностью, и осуществлённые процессы испарения и атомизации в пламени.

В ААА (как и в АЗСА) эмпирически строят зависимость $A = f(c)$ с помощью образцов, содержащих точно известные кол-ва определяемого элемента. Если общий состав этих образцов идентичен анализируемому, то систематич. погрешность может практически отсутствовать. В противном случае из-за указанных влияний на стадии испарения аэрозоля и атомизации возможны большие ошибки анализа. Сущест. роль при этом играют и дисперсность аэрозоля и качество распыляющего устройства.

ААА с плазменной атомизацией широко применяется в промышленности, медицине, экологии и др. Наиб. успешно производятся определение щелочных, щёлочно-земельных металлов, серебра, меди, железа, марганца.

Существуют разл. методы с неплазменной атомизацией (напр., с использованием дугового, искрового, в т. ч. СВЧ-, разрядов). Однако наиб. распространённым получил метод с электротермич. атомизацией проб (ЭТА). В этом методе атомизатор представляет собой трубчатую графитовую печь сопротивления, нагреваемую в атмосфере аргона электрич. током. Раствор пробы вводится сквозь отверстие на внутр. стенку печи или графитовую пластинку внутри печи, где проба высушивается, проходит термообработку, и затем пары поступают в раскалённую полость печи. При такой обработке пробы атомизация происходит полностью.

Свет от ЛПК направляется вдоль оси графитовой трубки, проходит сквозь атомные пары и попадает на входную щель спектрофотометра. Интенсивности I_x и I_0 регистрируются фотоелектрич. приёмником. Благодаря быстрому разогреву печи на стадии атомизации, импульсному поступлению паров в зону поглощения света в малому объёму этой области мгновенная концентрация атомов значительно выше, чем при плавневой атомизации. Если при этом используется малоинерционная регистрация поглощения, то пределы обнаружения элементов резко (на 4—5 порядков) улучшаются. Поэтому метод ААА с электротермич. атомизацией особенно хорошо применять при определении

микрочислечств. Так, напр., кадмий, цинк, медь, серебро с помощью этого метода регистрируются в кол-вах $\sim 10^{-12}$ — 10^{-14} г; при массе пробы 0,001—0,005 г это составляет 10^{-9} — $10^{-6}\%$, что является рекордным для аналитич. методов. Кроме того, с помощью метода ААА возможен непосредственный (без растворения) анализ некр-ых веществ, однако при этом возникают трудности с градуировкой и несколько ухудшается воспроизводимость. Тем не менее метод нашёл применение при определении примесей кремния, железа, кальция и т. п. в веществах высокой чистоты, что важно, напр., при контроле качества материалов для полупроводниковой техники, оптоэлектроники и др.

В ААА с аэлектротермич. атомизацией комбо графитовых твёрдых печей используют, напр., атомизаторы в виде вольфрамовой спирали. Они дают возможность обнаружить мн. элементы, содержание к-рых в растворе 10^{-14} — 10^{-18} г. Совр. установки для ААА позволяют производить анализа (с погрешностью не выше 0,05—0,1) в пробах, содержание определяемых элементов в к-рых $\sim 10^{-3}$ — $10^{-7}\%$.

Наиб. чувствительным С. а. является анализ с лазерным возбуждением спектра (для этого применяют перестраиваемые лазеры на красителях). Техника атомизации в этом случае мало отличается от используемой в ААА. Благодаря монохроматичности и высокой мощности излучения лазера возбуждается значительно большее число атомов определяемого элемента, чем при термич. возбуждении. Чувствительность обнаружения элементов при лазерном возбуждении чрезвычайно высока. Есть сведения, что удалось определить свинец в воде при содержаниях до $10^{-10}\%$ (1 мкг/мл).

Лит.: Зайдель А. Н., Основы спектрального анализа, М., 1965; Львов В. В., Атомно-абсорбционный спектральный анализ, М., 1966; Русанов А. К., Основы количественного спектрального анализа руд и минералов, 2 том., М., 1978; Спектральный анализ чистых веществ, Л., 1971; Лазерная аналитическая спектроскопия, М., 1986. В. В. Недаев.

Молекулярный спектральный анализ

С помощью молекулярного С. а. (МСА) осуществляют качественное (идентификация) и количественное определение индивидуальных веществ или вещества в смесях. Это могут быть известные молекулярные вещества, новые стабильные и нестабильные молекулы и частицы (ионы, радикалы и др.), разл. конформеры одних и тех же молекул. Методом МСА исследуют вещества в любых агрегатных состояниях, растворах, плазме, адсорб. слое и т. д. в широком диапазоне темп-р (от близких к абс. нулю до сотен и тысяч градусов). Информативность метода определяется строгим индивидуальностью спектров молекул, а сочетание методов анализа по неск. видам спектров ещё более увеличивает надёжность определения состава анализируемой пробы. Установлены общие закономерности, связывающие спектры веществ с их строением.

Методы МСА основаны на сравнении измеренных молекулярных спектров исследуемого образца со стандартными спектрами индивидуальных веществ (или расчётными спектрами, когда спектры индивидуальных соединений неизвестны). Используют все виды молекулярных спектров, характерных для взаимодействия вещества с эл.-магн. излучением (спектры поглощения, испускания, рассеяния, отражения, вращения плоскости поляризации, фотоэлектронной эмиссии). Измерения могут производиться в широком диапазоне длин волн — от 10^{-12} м (γ -излучение) до 10^3 м (радиоволны); диапазон частот 10^{16} — 10^8 Гц).

Молекулярный спектр является однозначной характеристикой молекулы, определяется её свойствами в целом, её структурой и свойствами входящих в неё атомов. В МСА используют электронные спектры (спектры поглощения в УФ- и видимой областях, спектры люминесценции), колебат. спектры (ИК-спектры поглощения и испускания, спектры комбинац. рассеяния), вращат. спектры (микроволновые), а также электронно-колебат. и колебательно-вращат. спектры и, кроме того, др.

виды спектров: рентгеновские (см. Рентгеноспектальный анализ), γ -спектры (см. Мессбауэровская спектроскопия), фотоэлектронные спектры (см. Фотоэлектронная спектроскопия), спектры ядерного магнитного резонанса (ЯМР), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР).

Для целей МСА могут служить и др. методы исследования: для оптич. спектров активных молекул — дисперсия вращения плоскости поляризации, поляриметрия в аэлектронной и колебательно-вращат. диатризма (в УФ-, видимой и ИК-обл-стях, в спектрах КР). С появлением лазеров стали интенсивно развиваться методы С. а., основанные на нелинейных эффектах, возникающих при взаимодействии вещества с лазерным излучением большой мощности; к ним относятся когерентное рассеяние света, вынужденное комбинац. рассеяние света (в т. ч. гиперкомбинац. рассеяние света, инверсное, усиленное поверхностью и др. виды комбинац. рассеяния света; см. также Нелинейная спектроскопия). Чувствительность МСА возросла как благодаря применению лазеров, так и за счёт использования новых методов регистрации спектров (многочанальные методы, в первую очередь фуьре-спектроскопия, фотокулич. спектроскопия) и применения низких температур (матричная изоляция, сверхзвуковые молекулярные пучки и др.). В некр-ых случаях МСА позволяют определять вещества в кол-вах до 10^{-12} г.

Качественный МСА позволяет по молекулярным спектрам идентифицировать индивидуальные вещества или устанавливать молекулярный состав исследуемого образца. Наиб. специфичны спектры вещества, содержащих в определ. интервале частот исследуемого диапазона большое число спектрально разрешённых линий или полос (число полос во вращат. спектрах газообразных веществ в микроволновом диапазоне достигает $\sim 10^4$).

Для повышения информативности МСА в некр-ых случаях измерение спектров комбинируют с др. методами идентификации веществ, напр. сочетают ИК-спектрометр и газовый хроматограф, что позволяет получать спектры индивидуальных компонент сложной смеси веществ. В связи с развитием фуьре-спектроскопии, резко поависшей чувствительности ИК-спектрометров поглощения, стало возможным измерять спектры отд. хроматографич. фракций при содержании исследуемого вещества $\sim 10^{-9}$ г. Сочетание ИК-спектрометров и спектрометров комбинац. рассеяния с микроскопом даёт возможность получать спектры микрообразцов размером ~ 1 мкм и исследовать распределение веществ на поверхности гетерогенных образцов.

Разнообразие МСА является структурно-групповой анализ, позволяющий определять в смеси не отдельные вещества, а классы веществ, имеющих общий спектральный признак, напр. органич. кислоты и икотены. Метод основан на наличии в молекулярных спектрах т. н. характеристических частот. Наиб. ярко это проявляется в колебат. спектрах. Напр., для всех нитрилов, содержащих группу $C\equiv N$, в спектре появляется полоса в области 2200—2300 cm^{-1} для всех тиоспиртов с группой $S-N$ в спектре появляются полосы в области 2500—2600 cm^{-1} , в спектрах всех органич. кислот имеются принадлежащие группе $COOH$ полосы в области 1600—1750 cm^{-1} .

Метод структурно-группового анализа позволяет определить класс, к к-рому принадлежит вещество, и наличие тех или иных функциональных групп. Так, в ароматичности применяется метод анализа нефтяных фракций на содержание непредельных углеводородов по спектрам комбинац. рассеяния света.

Качественный МСА производят путём сравнения получаемого спектра со стандартными спектрами. Созданы библиотеки, включающие десятки тысяч спектров. Анализ существенно ускоряется и упрощается при использовании ЭВМ, в память к-рой вводятся стандартные спектры. В ЭВМ сравнение может вестись как по

всему спектру, так и по отд. спектральным признакам, измеряемые спектры можно вводить непосредственно в память ЭВМ. Если в библиотке искомого спектра нет, то спектр анализируемого вещества сопоставляют с теоретическими расчетными. С помощью систем искусств. интеллекта рассчитывают колебат. спектры для наиб. вероятных структур молекулы на основании заложённых в банк данных сведений о ал.-оптич. и энергетич. параметрах молекулы. Методами *квантовой химии* рассчитывают электронные и колебат. спектры достаточно сложных молекул, к-рые также могут использоваться при идентификации веществ.

В науч. исследованиях часто проводят МСА неустойчивых и короткоживущих молекул, а также анализа промежуточных продуктов хим. реакций и изучение их кинетики. Для этой цели разработаны скоростные методы возбуждения и регистрации спектров. Так, с помощью фурье-спектрометров получают ИК-спектры за время до 10^{-8} с, при импульсном лазерном возбуждении — спектры комбинац. рассеяния за время $\sim 10^{-8}$ с, спектры поглощения и флуоресценции за время $\sim 10^{-12}$ с и даже 10^{-15} с (см. *Фемтосекундная спектроскопия*).

При низких темп-рах время жизни неустойчивых молекул возрастает, что позволяет изучать их обычными спектральными методами. Одновременно за счёт сужения линий, сопровождающегося ростом их пиковой интенсивности, а также лучшего разрешения тонкой структуры существенно возрастает чувствительность и информативность спектров. В т. и. методе матричной коаляции исследуют спектры развалённых твёрдых растворов, когда исследуемое вещество заключено в твёрдой матрице инертного газа (Ne, Ar, Kr, Xe), азота и др. газов при темп-рах ок. 10 K; хорошо разрешены узкие спектры вещества получают методом молекулярных пучков, когда находящийся под большим давлением смесь паров вещества и газа-носителя (обычно Ne, Ar) со сверхзвуковой скоростью вытекает через узкое сопло, адiabатически охлаждается до темп-ры ниже 1 K и затем регистрируются спектры. В этом случае могут быть спектроскопически идентифицированы даже такие неустойчивые частицы, как *ван-дер-ваальсовы молекулы*.

Количественный МСА наиб. часто проводят по спектрам поглощения. В основе метода лежит *Бугера — Ламберта — Бера закон*:

$$I = I_0 \exp(-\epsilon c l), \quad (3)$$

где I_0 и I — интенсивности падающего и прошедшего через образец излучения, l — толщина слоя, c — концентрация вещества. Коэф. поглощения ϵ (молярный коэф. поглощения) определяет поглощат. способность вещества на частоте излучения. Закон Бугера — Ламберта — Бера можно использовать в МСА только в отсутствие зависимости ϵ от c , к-рая обычно связана с наличием в растворе *межмолекулярных взаимодействий* (напр., ассоциации). МСА по спектрам поглощения веществ и газов так же измерения более сложны.

На практике обычно измеряют *оптическую плотность*

$$D = \ln(I_0/I) = \epsilon c l. \quad (4)$$

Если в смеси имеется n не реагирующих между собой веществ, то оптич. плотность на частоте ν аддитивна:

$D_\nu = \sum_{i=1}^n D_{i\nu}$. Это позволяет проводить полный или частичный анализ многокомпонентных смесей. При этом задача сводится к измерениям оптич. плотностей в m точках спектра смеси и решению системы ур-ний:

$$D_k = \sum_{i=1}^n D_{ki} \quad (k=1, 2, \dots, m). \quad (5)$$

Необходимо знать величины коэф. ϵ для каждой из компонент смеси при используемых значениях частот. Если соотношение (5) строго не выполняется, для проведения анализа смесей строят градуировочные кривые зависимости D от c .

Количественный МСА обычно производят с помощью спектрофотометров, измеряющих соотношение I/I_0 в широком диапазоне ν . Если полоса поглощения исследуемого вещества изолирована и не перекрывается с др. полосами поглощения смеси, то анализ многокомпонентной смеси может осуществляться по этой полосе (как и для однокомпонентного вещества) по ур-нию (4). Полоса может быть выделена при получении спектра в спектрометре, однако проще и дешевле её выделять с помощью светофильтра. В промышленности используют специальные анализаторы, имеющие набор светофильтров.

Количественный МСА по спектрам исчисления или комбинац. рассеяния света осуществляют путём сравнения полученных спектров со спектрами эталонных веществ, записанными в тех же условиях. Интенсивность линии определяемого вещества сравнивают с интенсивностью нек-рой линии стандартного вещества (метод «внеш. стандарта») или с интенсивностью линии стандартного вещества, добавляемого к исследуемому в известном соотношении (метод «внутр. стандарта»).

Флуоресцентный МСА основан на сравнении спектров свечения раствора исследуемого вещества со свечением эталонных растворов близкой концентрации. Метод обладает высокой чувствительностью, но уступает методам поглощат. спектроскопии по универсальности и избирательности. При использовании техники замороженных растворов (метод Шпольского; см. *Шпольский эффект*) информативность спектров флуоресценции резко возрастает, т. к. в этих условиях спектры обладают ярко выраженной индивидуальностью и резко различны даже для изомеров и молекул близкого строения. Напр., метод Шпольского даёт возможность проведения качеств. и количеств. анализа сложных смесей ароматич. углеводородов. Благодаря исключительно малой ширине спектральных линий в спектрах Шпольского удаётся достигнуть пороговой чувствительности обнаружения нек-рых ароматич. веществ ($\sim 10^{-11}$ г/см³).

Лит.: Б е л я я м и Л., Инфракрасные спектры сложных молекул, пер. с англ., 2 изд., М., 1968; Ж у д е в Ф р е я Л. С., Флуоресцентный анализ в биологии и медицине, пер. с англ., М., 1965; С и л ь в е р с т е й Я. Р., Б а с с е р г Е. Г., М о р р и л Т., Спектроскопическая идентификация органических соединений, пер. с англ., М., 1977; З л я ш б е р г М. Е., Г р и б о в Л. А., С е р о в В. В., Молекулярный спектральный анализ и ЭВМ, М., 1980; С м и т А., Прикладная ИК-спектроскопия, пер. с англ., М., 1982; В и д л о в Л. В., П е н т и Ю. А., Физические методы исследования в химии, т. 1—2, М., 1976; Ю. В. Локшин.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОВСКИЙ — см. Рентгеноспектральный анализ.

СПЕКТРОГРАММА (от *спектр* и греч. *grámma* — знак, буква) в оптике — функциональная зависимость к.-л. величин, характеризующей вещество или излучение, от спектрального аргумента (энергия фотонов, длины волны λ излучения, волнового числа $\nu = 1/\lambda$ и др.), зарегистрированная *спектральным прибором* в форме графика.

СПЕКТРОГРАФ (от *спектр* и греч. *gráphō* — пишу) — *спектральный прибор*, в к-ром приёмник излучения регистрирует одновременно весь оптич. спектр, развёрнутый по длинам волн на фокальной поверхности с помощью оптич. системы с диспергирующим элементом (призмы, дифракционной решётки, *шеллетом*, *шеллем*). Оптич. схема С. выбирается таким образом, чтобы на фокальной поверхности (желательно — плоскости) изображения входной щели в разных длинах волн были по возможности свободны от аббераций (в отличие от схем *монокроматоров*, где требование отсутствия аббераций относится лишь к изображениям, лежащим на выходной щели прибора).

Приёмниками излучения в С. служат фотогр. материалы, многоэлементные фотоэлектрич. приёмники (в виде «линеек» и «матриц»), *электронно-оптические преобразователи*. Если регистрирующее устройство приспособлено для исследования кинетики быстро меняющихся во времени спектров, то в зависимости от конструкции С. называют кино спектрографом, спектрохромографом, хроно-спектрографом. В. А. Никитин.

СПЕКТРОКОЛОРИМЕТР — *спектрофотометр*, предназначенный для измерений координат цвета или координат цветности цветовых стимулов (см. *Колориметрия*).

СПЕКТРОМЕТР — в широком смысле устройство для измерений функции распределения (спектра) некой ф-ции. величины f по параметру x . Ф-цию распределения $f(x)$ электронов по скоростям измеряет *бета-спектрометр*, атомов по массам — *масс-спектрометр*, гамма-квантов по энергиям — *гамма-спектрометр*, рентг. фотонов по энергиям, частотам или длинам волн — рентг. спектрометры (см. *Рентгеновая спектральная аппаратура*). При изучении резонансов — ядерного магнитного, электронного парамагнитного и др. — используются радиоспектрометры (см. *Радиоспектроскопия*).

В оптике С. принято называть *спектральные приборы* для измерений оптич. спектров с помощью фотоэлектрич. приёмников излучения. Если при этом в оптич. части применена схема *спектрографа*, то прибор в целом иногда называют спектрограф-спектрометром. В. А. Никитин.

СПЕКТРОМЕТР ПО ВРЕМЕНИ ПРОЛЁТА — прибор для измерения скорости v (энергии \mathcal{E}) частиц по времени пролёта ими заданного расстояния. Измеряется временной интервал между импульсами от двух детекторов частиц (сцинтилляционных, искровых или черенковских), ограничивающих т. н. прелётную базу. Для частицы с известным импульсом $p = mv\sqrt{1 - v^2/c^2}$ (m — масса частицы), к-рый может быть измерен, напр., магн. спектрометром, измерение v позволяет определить m , т. е. идентифицировать частицу. Если масса частицы известна (напр., протон, нейтрон), С. по в. п. позволяет измерять её импульс. Разрешающая способность по массе $\Delta m/n$ при заданном разрешении по скорости резко ухудшается с ростом энергии \mathcal{E} :

$$\Delta m/m = v^2(\Delta\beta/\beta), \quad \beta = v/c, \quad v = \mathcal{E}/m = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$$

При временном разрешении $\sim 10^{-10}$ с и прелётной базе $10^2 - 10^3$ м можно измерять скорость частиц с точностью $\Delta\beta/\beta = 10^{-3} - 10^{-4}$. Хотя газовые черенковские счётчики дают большую точность ($\Delta\beta/\beta = 10^{-6}$), С. по в. п. применить удобнее, если скорости частиц лежат в широком диапазоне. Это важно при поисках новых частиц. С. по в. п. сыграла важную роль в экспериментах по обнаружению ядр антигелия $\bar{\text{He}}$ и антинитра $\bar{\text{T}}$ (см. *Антивещество*).

С. по в. п. в сочетании с ускорителями и импульсными реакторами может быть использован для измерения не только заряженных, но и нейтральных частиц (нейтронов, К-мезонов и др.). В этом случае начало отсчёта времени задаётся импульсным источником частиц (см. *Нейтронная спектроскопия*). Лит.: Методы измерения основных величин ядерной физики, сост.-ред. Люк К. Л. Юан и Бу Цзянь-Сюан, пер. с англ., М., 1964; Выстраивающаяся электроника для регистрации ядерных частиц, М., 1970. Л. Г. Ландсберг.

СПЕКТРОМЕТРИЯ — оптическая (от *спектр* и греч. *metreo* — измеряю) — совокупность методов и теория измерений спектров эл.-магн. излучения и изучение спектральных свойств веществ и тел в оптич. диапазоне длин волн (~ 1 м — 1 мк). Измерения в С. осуществляются с помощью *спектральных приборов*. Осн. задачи С.: теория спектральных приборов, мо-

дельное рассмотрение условий измерений в типовых вариантах, разработка критериев сравнения приборов, способов оптимизации условий и режимов измерений с целью получения наиб. точных результатов за наим. время.

Теоретические основы спектрометрии. Оптич. сигнал $u(t)$ во времени t может быть представлен преобразованием Фурье в виде линейной комбинации гармонич. сигналов с частотами v :

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(v) \exp(i2\pi vt) dv,$$

где

$$S(v) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \exp(-i2\pi vt) dt.$$

При таком рассмотрении измерение спектра сводится к нахождению амплитуды и фаз комплексной ф-ции $S(v)$, описывающей спектр сигнала $u(t)$. Реальные возможности измерений связаны с рядом ограничений и альтернатив. Во-первых, приёмники излучения реагируют не на интенсивность излучения, а на поток, пропорциональный произведению $S(v) \cdot S^*(v) = |S(v)|^2$. Во-вторых, в обычной (не лазерной) С. излучение чаще всего некогерентно, т. к. испускается большим числом элементарных излучателей со случайными амплитудами и фазами (об особенностях С. когерентного излучения см. в ст. *Лазер, Лазерная спектроскопия*). Поэтому $u(t)$ — случайная ф-ция и, следовательно, $S(v)$ — случайная величина. Для детерминиров. описания случайного процесса излучения рассматривают спектр его мощности:

$$\Phi(v) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |u(t) \exp(-i2\pi vt) dt|^2.$$

Именно такой спектр измеряют с помощью реальных приёмников. Обратным преобразованием Фурье от $\Phi(v)$ является автокоррелл. ф-ция сигнала $u(t)$:

$$I(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u(t+\tau) u^*(t) dt.$$

Ф-ция $\Phi(v)$ и $I(\tau)$ связаны между собой преобразованиями Фурье:

$$\Phi(v) = \int_{-\infty}^{\infty} I(\tau) \exp(-i2\pi v\tau) d\tau,$$

$$I(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(v) \exp(i2\pi v\tau) dv.$$

Т. о., исходный процесс $u(t)$ может быть описан любой из ф-ций $\Phi(v)$ и $I(\tau)$, несущих в равной форме одно и то же кол-во информации. В связи с этим возможны два типа измерит. систем в С.

В приборах, измеряющих непосредственно спектр $\Phi(v)$, излучение направляется на устройство, обладающее свойством спектральной селективности (выделяет узкий интервал $(v, v + \delta v)$), и прибор регистрирует мощность выделяемой спектральной составляющей излучения. Полный спектр $\Phi(v)$ получается или последоват. перестройкой частоты — сканированием (одноканальные системы), или одновременным независимым приёмом излучения от мн. интервалов δv (многоканальные системы).

Во втором варианте С. в процесс распространения излучения вводится переменная временная задержка t и измеряется автокорреляц. ф-ция $I(t)$. Наиб. эффектив. это реализуется в двухлучевом *интерферометре Майкельсона* сканированием по разности хода $\Delta = ct$. Изменения сигнала приёмника при таком сканировании дают интерферограмму $I(\Delta)$, Фурье-образ k -рой представляет собой спектр $\Phi(\sigma)$, где σ — волновое число ($\sigma = 1/\lambda = v/c$, λ — длина волны). [Подробнее см. в ст. *Фурье-спектрометр*. Ниже рассматриваются методы измерения $\Phi(v)$.]

Инструментальный контур. Модельные описания процессов измерений в С. основываются на представлениях теории *линейных систем*. Спектральный прибор воздействует на измеряемый спектр — входной сигнал $\Phi_{вх}(\lambda)$, поэтому наблюдаемый спектр $\Phi_{вых}(\lambda)$ описывается в общем виде интегралом

$$\Phi_{вых}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{вх}(\lambda') \cdot A(\lambda, \lambda') d\lambda', \quad (1)$$

где $A(\lambda, \lambda')$ — *аппаратная функция* (АФ), или инструментальный контур, — индивидуальная характеристика измерит. прибора, зависящая от двух переменных: λ — ф-ция длины волны входящего излучения и λ' — приборной координаты, напр. спектральной шкалы прибора, по k -рой считается отклик прибора, т. е. ф-ция $\Phi_{вых}(\lambda)$.

Спектральные приборы чаще всего сочетают оптич. систему (формирующую оптич. сигнал на приёмнике, преобразующую его в электрич. сигнал) с приёмно-регистрирующей системой, на k -ую поступает электр. сигнал. Соответственно общая характеристика прибора A распадается на оптическую и электрическую АФ. Рассмотрим оптич. часть АФ.

Соотношение (1) позволяет указать способ определения контура $A(\lambda, \lambda')$. Пусть входной сигнал представляет собой монохроматич. волну $u(t) = \exp(-i2\pi\nu_0 t)$, спектр k -рой бесконечно узкая спектральная линия — дельта-функция $\delta(\lambda_0)$. Тогда

$$\Phi_{вых}(\lambda) = \delta(\lambda_0) \cdot A(\lambda, \lambda') = A(\lambda_0, \lambda'),$$

т. е. АФ есть отклик линейного прибора на δ -воздействие. Для спектральных приборов на основе монохроматич. такая ситуация реализуется при освещении входной щели излучением монохроматич. спектральной линии с шириной b_d , много меньшей спектральной ширины щели монохроматора. На спектрограмме линия с длиной волны λ_0 изображается прибором в виде контура колоколообразной формы, максимум k -рого располагается на делении шкалы $\lambda' = \lambda_0$, если шкала точна, или на ином значении $\lambda' \neq \lambda_0$, если шкала смещена по k — л. причинам. Ширина этого инструментального контура соответствует $\Delta\lambda$ ф-ции λ и в о. с. п. е. к. т. р. а. л. и о. ш. и р. и. ш. щ. е. л. и щ. $s_{\Delta\lambda}$ (учитывающей вклады дифракции, aberrаций, разъюстировок).

Форма измеренного контура может быть различной. При сужении щелей до размеров дифракц. уширения (эксплоатация щели) контур A приближается к виду $\text{sinc}^2 \lambda = (\sin \lambda/\lambda)^2$. В другом крайнем случае при достаточно широких щелях контур A приближается к треугольному; это объясняется тем, что контур A соответствует изменению сигнала приёмника при сканировании изображения входной щели поперёк выходной, при этом происходит свёртка двух П-контуров, k -рая и даёт в результате треугольный контур: $\Pi \cdot \Pi = \Lambda$. При промежуточных значениях ширины щелей треугольный контур сглаживается, что обычно удовлетворительно аппроксимируется гауссовым ф-цией (если aberrация не вносит асимметрии). Существование подчеркнуть, что в рассматриваемом случае аппаратная ф-ция A имеет ширину $s_{\Delta\lambda}$ в спектральных единицах (в шкале прибо-

ра λ'), но весь её контур соответствует одной фз. длине волны λ_0 монохроматич. входящего излучения.

Если входящее излучение содержит ряд линий в нек-ром диапазоне длин волн и каждая из них отображается прибором в виде контуров одинаковой формы, то говорят, что такой прибор обладает свойством спектральной инвариантности в данном диапазоне. В этом случае ф-ция A зависит только от разности аргументов; обозначим её: $a(\lambda - \lambda')$. Для такой ф-ции интеграл (1) описывает операцию свёртки к: $\Phi_{вых} = \Phi_{вх} * a$. Допущение об инвариантности является исходным в большинстве теоретич. работ по С. Но в реальных широкодиапазонных приборах (со смешными дифракц. решётками) инвариантность в рабочих режимах верою. не соблюдается, что приходится принимать во внимание при решении обратных задач — восстановления истинного спектра по измеренному.

Для линейчатого спектра на входе вводится характеристика прибора, называемая разрешением (возможность раздельного наблюдения двух близких линий равной интенсивности). Разрешение численно равно ширине ф-ции a , т. е. значению $s_{\Delta\lambda}$, т. к. при сближении двух линий λ_1, λ_2 до расстояния $s_{\Delta\lambda} = |\lambda_1 - \lambda_2|$ их инструментальные контуры a_1 и a_2 или сливаются в трансцендентный контур (при треугольной форме a), или разделяются лишь небольшим провалом (при дифракц. форме a ; *Резерв критерия*). Отношение длины волны к разрешению наз. *разрешающей способностью*: $R = \lambda/s_{\Delta\lambda}$, где $\lambda = (\lambda_1 + \lambda_2)/2$.

Кроме отклика на одиночную δ -функцию на входе важное значение для полноты модельного описания имеет др. предельный случай, когда входной сигнал обладает сплошным спектром (бесконечная последовательность δ -функций). Тогда при фиксирован. положении всех оптич. элементов монохроматора (при остановленном сканировании) в фокальной плоскости образуется континуум монохроматич. изображений входной щели, последовательно смещённых за счёт угл. дисперсии. Суперпозиция этой последовательности на выходной щели соответствует операции свёртки, в результате k -рой формируется выходящий поток. Контур его спектра, в отличие от АФ, наз. ф-цией пропускания (ФП). Длина волны, соответствующая максимуму ФП, наз. длиной волны прибора λ' , ширина контура ФП наз. выделяемым спектральным интервалом $\Delta\lambda'$, отношение $\lambda'/\Delta\lambda'$ — селективностью С.

Зная отклик прибора на два осн. вида тестовых сигналов — δ -функцию и сплошной фоп, можно применять интеграл (1) к описанию измерений двух осн. видов спектров — излучения и поглощения (точнее — пропускания, т. к. обычно измеряется не поток, поглощённый в веществе, а прошедший или отражённый поток). Спектр потока $\Phi_{вх}(\lambda)$ представляется суперпозицией линий или полос, описываемых произведениями век-рой пост. величины на нормированную к единице ф-цию распределения $f(\lambda) \leq 1$:

$$\Phi(\lambda) = \Phi_{макс} \cdot f(\lambda) \text{ — спектры излучения,}$$

$$\Phi(\lambda) = \Phi_0 [1 - f(\lambda)] \text{ — спектры поглощения.}$$

Одночная полоса в силу особенностей происхождения спектров (см. *Спектры оптические*) имеет контур $f(\lambda)$ колоколообразной формы, аппроксимируемый в первом приближении Гаусса функцией:

$$f(\lambda) \propto \exp(-4 \ln 2 [(\lambda - \lambda_0)/b_f]^2),$$

где λ_0 — положение максимума, b_f — ширина на полувысоте. Воздействие прибора на $f(\lambda)$ описывается в соответствии с (1) выражением

$$J(\lambda') = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) \cdot a(\lambda - \lambda') d\lambda. \quad (2)$$

Здесь $J(\lambda')$ — контур, наблюдаемый на выходе монохроматора в ходе сканирования, $a(\lambda - \lambda')$ — инструментальный контур, обладающий свойством инвариантности. Важно подчеркнуть, что при измерениях спектров поглощения или широких полос излучения инструментальный контур a в (2) должен соответствовать ФП и только при измерениях отс. линий излучения свёртка (2) осуществляется с АФ. Анализ выражения (2) показывает, что искажающее действие прибора тем больше, чем больше кривизна измеряемого контура, т. е. чем больше вторая производная $d^2f/d\lambda^2$. Поэтому в качестве количеств. характеристики искажений принимается отнот. уменьшение максимума контура (где вторая производная наибольшая), называемое δ_s с е в о й п о г р е ш н о с т ь ю $\delta_s = (J_m - J_{\text{из}})/J_m$. Эта погрешность пропорциональна квадрату отношения ширины контуров f и a . В гауссовом приближении $\delta_s = 1/2(\sigma_{\text{ФП}}/\sigma_f)^2$, если $\sigma_{\text{ФП}} < \sigma_f$, и измерения формы контуров спектров с погрешностью $\delta_s < 1\%$ возможны лишь при $\sigma_{\text{ФП}} < \sigma_f/7$.

В реальных приборах всегда имеет место расстояние излучения на оптич. элементах. Кроме того, возможно появление на выходе излучения, проходящего в переборах порядках дифракции. Поэтому для целей измерений сплошных (полосатых) спектров описание прибора с помощью контуров АФ и ФП, локализованных только в окрестности длины волны настройки, становится недостаточным. Необходимо учитывать также крылья контуров спектральных линий.

Для каждой λ на входе рассматривается контур АФ, заданный во всём рабочем диапазоне сканирования от начальной λ_n до конечной λ_k . В этом контуре, кроме осн. части спектральной линии шириной $\sigma_{\text{ФП}}$ в окрестности λ_0 , учитываются и протяжённые крылья от фона рассеянного излучения и дополнит. линии от др. порядков дифракции на делениях шкалы $\lambda' = m\lambda_0$, $m = 1, 2, 3, \dots$. Совокупность таких АФ для всех элементарных компонент λ_0 исследуемого сплошного спектра даёт полную картину свойств прибора в его рабочем диапазоне: $\lambda_n \leq \lambda_0 \leq \lambda_k$. Графически эта картина представляется трёхмерной поверхностью $a(\lambda_0, \lambda')$ и наз. полной аппаратной функцией (инвариантность в общем случае не предполагается).

Аналогичным образом рассматриваются ф-ции пропускания ФП для каждой длины волны настройки λ'' . Гл. части контуров ФП в окрестности λ' определяют полезный поток на выходе: $\Phi_{\text{вых}} \sim L_2(\lambda'')\delta\lambda$. Здесь $L_2(\lambda)$ — спектральное распределение спектральной плотности яркости источника, $\delta\lambda$ — ширина ФП на λ' . Интеграл по области крыльев ФП определяет поток мешающего излучения P посторонних длин волн. Подчёркнём, что спектр мешающего излучения определяется спектром входящего потока и может быть существенно шире диапазона $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, предусмотренного конструкцией прибора. Отношение потока к полезному потоку наз. уровнем мешающего излучения: $w = P/\Phi_{\text{вых}}$. Эта величина является важнейшей характеристикой спектральных приборов, нередко лимитирующей точность измерений.

Полный набор всех АФ и полный набор всех ФП несут одну и ту же информацию о приборе. В график. представлении совокупность всех АФ и ФП образует континуум взаимно перпендикулярных сечений одной п той же трёхмерной полной АФ.

Модельное описание с помощью ф-ций АФ и ФП, изложенное на примере монохроматоров с решётками, применяется также и к др. приборам и методам. С. о. спектрально-селективной фильтрацией или модуляцией — как однонаправленными, так и многоканальными (см. рис. 2 на ст. *Спектральные приборы*).

При достаточно полном устранении мешающего излучения, пренебрежимых размеров искажений монохроматич. изображений цели и отсутствии погрешнос-

тей в механизме сканирования можно полагать, что контуры АФ и ФП практически совпадают, и тогда $\sigma_{\text{ФП}} = \delta\lambda$ и $R = C$. В дальнейшем будем полагать, что эти равенства выполняются.

Приёмно-регистрационные системы и энергетические ограничения. В рамках оптич. С. обычно предполагается, что источники шумов не столь велики, чтобы невозможно было корректно ставить задачу измерения формы контуров полосатых спектров (или хотя бы интегральных интенсивностей в линейчатых спектрах). Условия измерений характеризуются значениями отн. шума к сигналу $M = \Phi_{\text{ш}}/\Phi_{\text{сиг}}$ [Ф — полезный поток, $\Phi_{\text{ш}}$ — поток, эквивалентный шуму приёмно-регистрающих систем (ПРС)], причём в С. значения $M \gg 1$, а методами с меньшим значением M решают задачи выделения сигнала на фоне шумов в общей теории оптико-электронных приборов. Используемые в С. ПРС разнообразны. Применяются и фотоэлектронные приёмники с уровнем шума, зависящим от сигнала (фотонный шум), и тепловые приёмники с уровнем шума, не зависящим от потока и имеющим равномерный частотный спектр (белый шум); и те и другие могут работать в сочетании с ФВМ. Универсальных моделей для всех видов ПРС нет. Рассмотрим, напр., линейную модель типа (2):

$$F(t') = \int_{-\infty}^{\infty} J(t)h(t-t')dt,$$

где $F(t')$ — регистрируемый сигнал, $J(t)$ — сигнал приёмника, воспринимающего изменения потока во времени от сканирующего монохроматора, $h(t-t')$ — импульсный отклик ПРС (реакция на δ -импульс на входе), фурье-образ k -рого в пространстве частот, $k(f)$, наз. передаточной ф-цией. Если в ПРС колебания сигнала несильны и превалирует инерционное звено (напр., АС-фильтр шумов с постоянной времени τ), то имеет место простая связь т. с о х в а т я е м о й ф-цией $k(f)$ полосой частот Δf : $\tau = 1/\Delta f$. Значения т. определяются инерционными искажениями контура входного сигнала J , а значениями Δf — уровнем шумов на выходе.

Искажения контура J характеризуются и инерционной погрешностью δ_s (имеющей аналогично δ_s смысл отнот. снижения максимума контура). При умеренных скоростях сканирования ($v < 0,2 \sigma_f/\tau$, где σ_f — ширина J в единицах спектральной шкалы) имеет место приближённое выражение $\delta_s \approx 2,8(v\tau/\sigma_f)^2$. Напр., измерения формы J контуров с погрешностью $\delta_s < 1\%$ возможны лишь за время $\delta t/v$, превышающее в 17 раз постоянную времени τ .

Инерционные погрешности могут быть уменьшены построением более сложных ПРС высших порядков или переходом к шаговому сканированию с отсчётом и усреднением сигнала на каждом шаге.

Если в системе применён приёмник с полностью среднеквадратичного белого шума в единичной полосе частот $\Phi_{\text{ш}}[\text{Вт} \cdot \text{Гц}^{-1/2}]$ и эта плотность не зависит от сигнала, то приведённый ко входу уровень шумов в системе с полосой АФ будет $\Phi_{\text{ш}} = \Phi_{\text{ш}} \sqrt{\Delta f}$. Общее выражение для потока, проходящего через оптич. систему, имеет вид $\Phi = L_2 G \delta\lambda (q - \text{коэф. потерь}, G - \text{геометрический фактор системы})$. Отсюда получается выражение для отношения сигнала к шуму, $M = \Phi/\Phi_{\text{ш}}$, а находясь общие энергетич. условия, определяющие диапазоны возможностей измерения систем рассматриваемого типа:

для случая измерений полосатых спектров излучения и поглощения

$$\frac{M\sqrt{\Delta f}}{(\delta\lambda)^2} = Q(\lambda) = L_2(\lambda)q(\lambda)R_{\text{диф}} \frac{G'}{\Phi_{\text{ш}}} \quad (3)$$

(G' — вертикальная составляющая геом. фактора приёмника);

для случая измерений линейчатых спектров излучения

$$\frac{M\sqrt{\Delta f}}{\epsilon_{\text{эф}}} = Q_{\text{лин}}(\lambda) = (L, \Delta\lambda)_{\text{лин}} q(\lambda) R_{\text{диф}} \frac{G'}{\Phi_{\text{ин}}}. \quad (4)$$

Левая часть равенства (3) соответствует определению энергетического фактора Q как отношения сигнал/шум при единичной полосе частот Δf и единичном выделяемом спектральном интервале $\Delta\lambda$. Наряду с Q пользуются также фактором качества K , значения которого не зависят от выбора спектральной шкалы. Он получается из Q заменой $\Delta\lambda$ на $R = \lambda/\epsilon_{\text{эф}} \approx C = \lambda/\delta\lambda$:

$$K = R^2 M \sqrt{\Delta f} = \lambda^2 Q(\lambda) = \sigma^2 Q(\lambda) \sigma,$$

$$K_{\text{лин}} = R M \sqrt{\Delta f} = \lambda Q_{\text{лин}}(\lambda) = \sigma Q_{\text{лин}}(\lambda) \sigma.$$

Величины Q , K характеризуют качество прибора. Чем больше Q и K , тем больше могут быть возможности измерений по разрешающей способности R , отношению сигнал/шум M и быстродействию (т. е. чем больше Δf , тем меньше постоянная времени фильтра τ , меньше иерципность и больше может быть скорость измерений). Правые части в соотношениях (3) и (4) показывают, от каких конструктивных параметров зависит качество прибора. Здесь видно, что вклад оптич. части прибора определяется только двумя величинами (если она согласована с источником и приёмником по геом. фактору) — коэф. потерь q и дифракц. пределом $R_{\text{диф}} = mNL$ (m — порядок спектра; N , L — частота дифракц. и ширина решётки), а вклады источника и приёмника — яркостью, плотностью шума и величиной G' , согласованной с параметрами монокроматора: $G' = hN/L$, где h , N — высоты щели и азелетта.

Системы равного качества (в смысле Q , K) могут быть реализованы в трёх основных конструктивных направлениях:

1. Максимум R — построение приборов высокой разрешающей способности (до 10^6) с большими решётками, работающих медленно ($\Delta f \approx 10^{-3}$ Гц, постоянная времени τ — до десятков секунд) при небольших значениях M .

2. Максимум Δf — построение приборов скоростной S . с устройствами быстрого сканирования и регистрации (до $\Delta f \approx 10^7$ Гц, $\tau \approx 10^{-6}$ с) при снижении R до 30–100.

3. Максимум M (до 10^8 при соответствующем диапазоне линейности) — построение приборов для прецизионных измерений контуров спектров при умеренных R и Δf (см. *Спектрофотометрия*).

С помощью критериев Q или K оцениваются в S . возможности и др. типов систем. При этом могут изменяться показатели степени у Δf или R (напр., R^2 в *Фурье-спектрометрах*) либо Δf может оказаться переуравненной константой, тогда параметр Δf переходит в правую часть соотношений (3) и (4) и т. д. Вводятся также дополнит. параметры, характеризующие спектральную или пространственную многоканальность, квантовый выход, характер шумов, протяжённость регистрируемых диапазонов, полное время измерений и т. н.

Оптимальные режимы, редукция. Общим свойством спектрометрич. систем является альтернативное соотношение между систематическими и случайными погрешностями (шумами). Напр., в монокроматорах при уменьшении ширины щелей $\epsilon_{\text{эф}}$ систематич. погрешности δ_s убывают пропорц. $\epsilon_{\text{эф}}^2$, но одновременно с такой же скоростью надет поток (сигнал) и возрастает относит. уровень шумов — случайная погрешность $\epsilon_{\text{ш}} = 1/M$. При увеличении $\epsilon_{\text{эф}}$, напротив, растут систематич. δ_s , но убывают случайные погрешности $\epsilon_{\text{ш}}$. В благоприятных ситуациях (гладкие спектры, «мощный» прибор в смысле Q) может существовать диапазон значений $\epsilon_{\text{эф}}$, где обе погрешности пренебрежимы, но нередко такой диапазон отсутствует и возникает задача

поиска оптич. значения $\epsilon_{\text{эф}}$ по подходуемому критерию. Выбор критерия зависит от того, будет ли применяться в ряде Q и K данных (методы решения обратных задач S . — нахождение истинного контура спектра по наблюдаемому).

Редукция прежде всего требует хорошего знания полной АФ прибора. Напр., если измерения описываются свёрткой типа (2): $J = f * a$, то для Фурье-образов имеет место равенство $\tilde{J} = \tilde{f} \tilde{a}$, и если \tilde{a} известна точно, а J не содержит шумов, то редукция эффективно осуществляется делением Фурье-образов: $\tilde{f} = \tilde{J}/\tilde{a}$. Наложение шумов или неполнота знания \tilde{a} резко ограничивают возможности редукции.

Если результаты измерений предполагаются использовать непосредственно (без редукции), то подходящим критерием оптимальности является общее требование минимума погрешностей, что формально сводится к отысканию таких значений регулируемых параметров (ширины оптической и электрической АФ), при к-рых сумма систематических (целевой и иерципной) и случайной погрешностей минимальна. Характер взаимосвязей в оптич. режиме можно выразить следующим образом:

$$(\text{точность})^2 \times (\text{скорость}) \approx \text{const} \cdot (b^4 \cdot Q^2).$$

Здесь точностью названа величина, обратная суммарной погрешности, а скоростью — величина $v = b/\delta$, где δ — время регистрации полосы шириной b . Существование, что точность и скорость находятся в альтернативном соотношении, показатель степени точности (4) определяет, насколько она критична, а показатель степени у параметров b и Q , от к-рых зависит константа справа, показывают, что структурность измеряемого спектра влияет на точность и производительность измерений сильнее, чем «мощность» спектрометра.

Лит.: Толоцкий Ю. А., Новые спектральные приборы, Л., 1978; Мишин и Ковалев М. М., Теоретические основы оптико-электронных приборов, 2 изд., Л., 1983; Миллер Д. Ж., Обнаружение и спектрометрия слабых источников света, пер. с англ., М., 1979; Никитин В. А., Теоретические основы методологии прецизионной спектрофотометрии, Л., 1981.

СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР — спектральный прибор для измерения угла вращения плоскости поляризации оптически активным веществом для излучений с разл. длинами волн (см. *Поляриметрия*).

СПЕКТРОРАДИОМЕТР — спектральный прибор для измерения фотометрич. характеристик (потока, светимости, силы света, яркости и др.) источников оптического излучения. По общей схеме и конструкции S . подобны спектрофотометрам, но имеют спец. осветители, позволяющие сравнить исследуемый поток с потоком от референтного источника (операция фотометрирования), встроенного в прибор или расположенного вне его. Для измерений спектров удалённых излучателей S . снабжаются спец. осветителями-телескопами или приставками к большим стационарным оптическим телескопам.

СПЕКТРОРЕФРАКТОМЕТР — спектральный прибор для измерения зависимости показателя преломления образцов материалов от длины волны излучения (см. *Рефрактометр*).

СПЕКТРОСКОП — простейший спектральный прибор для визуального наблюдения спектров. Обычно строится по схеме призменного спектрографа, в фокальной плоскости к-рого помещается матовое стекло.

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМВОЛ Z , характеризующая зарядовое состояние атома или иона; $Z = Z_n - N + 1$, где Z_n — заряд атомного ядра (в единицах элементарного электр. заряда), N — число электронов в атомной системе. Т. о., для нейтральных атомов $Z = 1$, для однократно положительных ионов $Z = 2$, для многоядерных ионов $Z \gg 1$.

В спектроскопии С. с. часто указывают римскими цифрами рядом с хим. символом, напр. Fe XXVI ($Z = 26$) означает ион Fe^{24+} .

С. с. определяет масштаб величины разл. характеристик ионов. Так, расстояние между уровнями энергии и потенциал ионизации для ионов с одинаковым числом электронов $\propto Z^2$, длина волны излучения $\propto Z^{-2}$, вероятность излучат. переходов $\propto Z^4$, характерный радиус иона $\propto Z^{-1}$, сечения возбуждения и ионизации электронами $\propto Z^{-4}$ и т. д.

СПЕКТРОСКОПИЯ (от *спектр* и греч. *σκοπέω* — смотреть) — область физики, посвящённая исследованию распределения интенсивности ал.-магн. излучения по длинам волн или частотам (в более широком смысле С. — исследование разл. спектров). Методами С. исследуют уровни энергии и структуру атомов, молекул и образованных из них макроскопич. систем, изучают квантовые переходы между уровнями энергии, взаимодействия атомов и молекул, а также макроскопич. характеристики объектов — темп-ры, плотность, скорость макроскопич. движения и т. д. Важнейшие области применения С. — спектральный анализ, астрофизика, исследование свойств газов, плазмы, жидкостей и твёрдых тел.

По типам спектров различают эмиссионную и поглощающую спектры излучения, а также отражательную С., исследующую спектры поглощения. По типу исследуемых объектов С. делится на атомную (см. *Атомные спектры*) и молекулярную (см. *Молекулярные спектры*), спектроскопию плазмы и С. вещества в конденсированном состоянии, в частности *спектроскопию кристаллов*. В 1970—80-х гг. возникли спектральные исследования поверхностей и тонких плёнок — С. поверхности.

По диапазонам длин волн (в порядке убывания) или частот (в порядке возрастания) выделяют: *радиоспектроскопию*, *микроволновую спектроскопию*, *субмиллиметровую спектроскопию*, *инфракрасную спектроскопию*, *оптическую спектроскопию* (включающую ближнюю ИК-, видимую и частично УФ-области спектра и выделенную гл. обр. по прозрачности оптич. материалов — стекла, кварца и др.), *ультрафиолетовую спектроскопию*, *рентгеновскую спектроскопию*. По характеру взаимодействия излучения с веществом С. подразделяют на *линейную (облучную) С.* и *нелинейную спектроскопию*, к-рая возникла благодаря применению лазеров для возбуждения спектров. Применение перестраиваемых лазеров на растворах красителей и полупроводниковых диодных лазеров, а также использование электронных цифровых методов регистрации спектров позволили достичь очень высокого спектрального разрешения и высокой точности спектральных измерений.

С. разделяют также по методам возбуждения и наблюдения спектров. Широкое применение получили акустооптическая С., когерентная С., С. напыления, С. гетеродинамизация, модуляционная С., многофотонная С., фемто- и пикосекундная С., С. фононного аха, квантовых биевней и др. методы *лазерной спектроскопии*. Существ. развитие получила *фурье-С.* с использованием *фурье-спектрометров* высокого разрешения.

Эксперим. исследование спектров производят с помощью *спектральных приборов* — монохроматоров, спектрометров, спектрографов, спектрофотометров, спектроанализаторов.

К С. в широком смысле относят также *ядерную спектроскопию*, в к-рую включают альфа-, бета-, гамма-спектроскопию, а также спектроскопию нейтронов, нейтроны и др. элементарных частиц. Распределение атомных частиц по массам и энергиям изучает *масс-спектропия*, интенсивности звука по его частоте — *акустическая спектроскопия*, электронов по энергиям — *фотоэлектронная спектроскопия*, рентгеноэлектронная спектроскопия, времяоптимальная спектроскопия, мессбауэровская спектроскопия и т. д.

Е. А. Югов.

СПЕКТРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛОВ — раздел спектроскопии, изучающий разл. типы спектров кристаллич. веществ в широком диапазоне длин волн. Наиб. информативны спектры в УФ-, видимом и ИК-диапазонах. Теоретич. основа С. к. — квантовая теория твёрдого тела. С. к. включает абсорбционную С. к. (исследование спектров поглощения), эмиссионную С. к. (исследование спектров излучения), спектроскопию рассеяния и отражения. В С. к., помимо частотных зависимостей процессов поглощения, излучения, рассеяния и отражения, изучают поляризац. характеристики взаимодействия кристаллов с излучением (см. *Поляриметрия*). В С. к. исследуют также изменение спектральных характеристик под внеш. воздействием — при изменении темп-ры, при вложении электрич. поля (*Штарка эффект*), магн. поля (*Зеемана эффект*, *Фарадея эффект*), механич. деформаций и т. д.

В абсорбционной С. к. определяют зависимость поглощения образцов от длин волн падающего излучения; в разл. областях спектра коэф. поглощения может составлять от 10^{-2} до 10^8 см $^{-1}$, соответственно образцы должны иметь толщины от десятков см до микрон. Для исследования очень сильно поглощающих образцов используют спектроскопию отражения, позволяющую по *Френеля формулам* получить коэф. отражения и поглощения света. По поляризац. характеристикам определяют двулучепреломление и дихроизм кристаллов.

Спектроскопия рассеяния исследует частотную зависимость рассеянного кристаллом излучения, а также изменение частоты рассеянного света, связанного с динамик. процессами в кристалле. К таким видам рассеяния относятся *Мандельштама — Бриллюэна рассеяние* и *комбинационное рассеяние света*.

Эксперим. методы С. к. аналогичны применяемым в др. методах спектроскопии (см. *Спектральные приборы*, *Спектрометрия*). Характерные ширины спектральных полос (10^3 см $^{-1}$) связаны с осп. веществом кристалла, спектральные линии поглощения и излучения шириной от дес. сотен до единиц см $^{-1}$ (при комнатной темп-ре) принадлежат примесям и др. дефектам кристалла. Для исследования тонкой структуры спектров образцы охлаждают до азотных (77 К), гелиевых (4,2 К) и более низких темп-р, при этом ширины линий составляют доли см $^{-1}$.

С. к. позволяет получать информацию о системе уровней энергии кристалла, о механизмах взаимодействия света с веществом, о переносе и преобразовании энергии возбуждения в кристалле, фотохим. реакциях и фотопроводимости. С. помощью С. к. можно также получить данные о структуре кристаллич. решётки, о характере дефектов, в частности примесных центров *люминесценции* в кристаллах. С. к. исследует влияние поверхности кристалла на его спектр, *многофотонные процессы* при лазерном возбуждении и нелинейные эффекты в кристаллах (см. *Лазерная спектроскопия*, *Нелинейная спектроскопия*). В С. к. широко используется теория групп, к-рая даёт возможность учесть свойства *симметрии кристаллов*, т. е. установить симметрию волновых ф-ций и найти *отбора правила* для квантовых переходов в кристалле.

На данных С. к. основаны применения кристаллов в качестве активных сред лазеров, элементов полупроводниковой техники, люминофоров, преобразователей света, оптич. материалов, ячеек для записи информации. Методы С. к. используются в спектральном анализе.

Лит. см. при ст. *Спектры кристаллов*. Э. А. Смирнёнок.
СПЕКТРОФЛУОРИМЕТР — спектральный прибор для измерений спектров *люминесценции*. Обычно содержит два независимых работающих *монохроматора*. Первый из них выделяет из сплошного спектра излучения источника спектральные интервалы, обеспечивающие возбуждение фотолуминесценции исследуемого образца. Люминесценция наблюдается в направлении,

перпендикулярном освещении, и её спектр измеряется с помощью второго монохроматора и соответствующего приёмника («измерительный» канал). Часть выделенного первым монохроматором возбуждающего излучения направляется светодетелем в «опорный» канал со своим приёмником. В блоке регистрации осуществляется фотометрирование — измеряется отношение сигналов в измерит. и опорном каналах. Применяются два осн. режима работы: измерение спектра люминесценции для данной длины волны возбуждающего излучения (сканирование осуществляется вторым монохроматором, а настройка первого фиксирована) и измерение спектра возбуждения для данной длины волны люминесценции (сканирование осуществляется первым монохроматором, а настройка второго фиксирована). В автоматич. серийных С. обычно имеется встроенная ЭВМ, корректирующая результаты измерений с учётом зависимости яркости источника, пропускания монохроматоров и чувствительности приёмников от длины волны для получения данных о *квантовом выходе* люминесценции. В. А. Никитин.

СПЕКТРОФОТОМЕТР — спектрометр, предназначенный для измерений и регистрации времени затухания люминесценции при разл. длинах волн оптич. излучения.

СПЕКТРОФОТОМЕТР — спектральный прибор для измерений фотометрич. параметров и характеристик веществ, сред и тел путём определения отношения двух потоков оптич. излучения — потока, падающего на образец, и потока, взаимодействовавшего с образцом (отражённого или прошедшего через него). См. *Спектрофотометрия*. В. А. Никитин.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ — совокупность методов фотометрирования потоков оптич. излучения от источников излучения или после его взаимодействия с образцами в зависимости от длины волны; объединяют разд. *спектрометрии, фотометрии и метрологии*. С. источник излучения наз. спектрометрической лампой λ и μ ; она занимается измерениями энергетич. характеристик излучения и излучателей (потока силы света, светимости, яркости, освещённости и т. п.). В узком смысле под С. понимают теорию и методологию измерений фотометрич. характеристик образца, безразмерных коэф., определяемых отношением потоков: $X = \Phi/\Phi_0$ (где Φ_0 — поток, падающий на образец, Φ — поток, наблюдаемый после взаимодействия с образцом); в зависимости от направлений освещения и наблюдения величина X — коэф. пропускания, отражения или рассеяния. Специфич. случай С. — метод *нарушенного пологого внутреннего отражения*.

Значения коэф. X зависят не только от свойств измеряемого образца — оптич. постоянных (*предела преломления показателя* n и главного показателя поглощения k), однородности, формы и состояния поверхности, но и от длины волны λ и условий измерения [направлений освещения и наблюдения φ , положения освещаемого участка на образце (z), поляризации, темп-ры]. Поэтому один и тот же образец может иметь разные значения X в разных условиях измерений.

В прецизионной С. твёрдых материалов и покрытий для правильной интерпретации результатов измерений в некогерентном излучении вводится представление о многомерной *аппаратурной функции* измерений (АФИ) $A(\lambda, \varphi, z)$. Ширина АФИ по координатам λ , φ , z соответствует спектральному ($\delta\lambda$), угловому ($\delta\varphi$) и пространственному (δz) интервалам, выделяемым в данной схеме измерений. Каждое измеренное значение X и его погрешность ΔX рассматриваются как результат операции свёртки многомерных φ -ций $X(\lambda, \varphi, z) * A(\lambda, \varphi, z)$ в данных конкретных условиях, описываемых комбинацией параметров λ , φ , z , $\delta\lambda$, $\delta\varphi$, δz (при известных поляризации и темп-ре) с соответствующими допусками по каждому из параметров. Фундациональные зависимости X от параметров λ , φ , z измеряются так: один из параметров сканируется, а

два других фиксированы. Так получают φ -ции распределения — спектры $X(\lambda)$, индикатрисы $X(\varphi)$, топограммы $X(z)$. Эти распределения тем ближе к истинному, чем меньше ширины АФИ $\delta\lambda$, $\delta\varphi$, δz , использованные при измерениях; уменьшение же ширины АФИ лимитируется энергетически, т. к. потоки излучения Φ и Φ_0 пропорц. *геометрическому фактору* $G \approx \delta\lambda(\delta\varphi)^2(\delta z)^3$. Это приводит к альтернативному соотношению между случайными погрешностями из-за шумов и систематич. погрешностями из-за конечности ширины АФИ.

Теоретически для идеально однородного материала с топограммой $X(z) = \text{const}$ и при хорошо известных зависимостях его оптич. характеристик от длины волны $n(\lambda)$ и $k(\lambda)$ можно рассчитать $X(\lambda)$ и $X(\varphi)$ по *Френеля формулам* для поглощающих сред, но их применение ограничено несовершенством формы и структуры реальных образцов. Эксперим. топограммы хорошо отполированными пластинок (зеркал) свидетельствуют об остаточных неоднородностях $\sim 10^{-2}-10^{-3}$, причём их распределения заметно зависят от времени. Этот предел «идеальности» поверхности эталонов и стандартных образцов на оптич. материалах в конечном счёте ограничивает и точность спектрофотометрич. исследований твёрдых тел в целом.

В С. жидкостное модальное описание процесса измерений значительно упрощается, т. к. обычно применяются унифициров. схемы измерений; во всех серийных спектрофотометрах почти параллельный пучок падает по нормали на типовую кювету с исследуемой жидкостью.

Вещества в газовой фазе в С. не исследуются. Осн. прибор, используемый в С., — спектрофотометр (см. *Спектральные приборы*). Об измерениях в когерентном лазерном излучении см. в ст. *Фотометрия импульсная*.

Лит. см. при ст. *Спектрометрия, Спектральные приборы*. В. А. Никитин.

СПЕКТРЫ КРИСТАЛЛОВ — спектры поглощения, люминесценции, рассеяния, фотопроводимости кристаллов в широком диапазоне длин волн. Наиб. информативны С. к. в оптич. диапазоне. По С. к. изучают частотные зависимости характеристик поглощения, рассеяния и люминесценции кристаллов (см. *Спектроскопия кристаллов*), а также поляризац. зависимости (см. *Поляриметрия*).

С. к. обусловлены *квантовыми переходами* между уровнями энергии, принадлежащими как осн. веществу кристалла, так и его примесям. Эти переходы могут быть связаны с изменением только энергетич. состояния электронов (электронные спектры) или только энергий колебат. состояний атомов кристаллич. структуры (фононные спектры), а также с их одноврем. изменением. Электронные С. к. обусловлены электронными переходами между уровнями энергии атомов осн. вещества и примесей. Электронные уровни осн. вещества образуют энергетич. зоны (см. *Зонная теория*). Верхняя заполненная зона наз. валентной, а нижняя пустая — зоной проводимости. Межзональные электронные переходы образуют интенсивные полосы поглощения с коэф. поглощения до 10^6 см^{-1} — т. н. основное или фундаментальное поглощение. ДВ-край полосы фундам. поглощения соответствует ширине запрещённой зоны. Частотная зависимость края фундам. поглощения определяется структурой зоны (т. е. плотностью энергетич. состояний вблизи края зоны проводимости и плотности валентной зоны), а также тем, являются ли переходы между зонами прямыми — без участия фононов или происходят с участием фононов. Исследование края фундам. поглощения несёт, таким образом, информацию о структуре зон.

ДВ-край фундам. поглощения $\epsilon_{\text{св}}$ может лежать в УФ-области, напр. у алмаза ($\epsilon_{\text{св}} = 5,4 \text{ эВ}$), шёлочногогалогенидных кристаллов (у NaCl $\epsilon_{\text{св}} = 8,6 \text{ эВ}$). В более

длинноволновой области лежит край фундам. поглощения у кристаллов типа A_nB_{3-n} (напр., у ZnS $\epsilon_g = 3,6$ эВ, у CdS $\epsilon_g = 3,4$ эВ), у кристаллов типа A_nB_2 (напр., у $AsGa$ $\epsilon_g = 1,52$ эВ) и кристаллов, образованных элементами IV группы периодич. системы элементов. В этих кристаллах, являющихся полупроводниками, даже при комнатной темп-ре в зоне проводимости находятся электроны, возбужденные тепловым движением. Органические кристаллы, элементарная ячейка к-рых состоит из одной или неск. молекул, обладают спектрами, сходными с молекулярными. Кристаллы, состоящие из насыщенных углеводородов, поглощают (как и исходные молекулы) излучение в далекой УФ-области. В спектрах кристаллов, построенных из ароматич. и гетероциклич. молекул, край фундам. поглощения лежит в ближней УФ- и сильной области спектра. Фундам. поглощение в них связано с возбуждением коллективизированных p -электронов.

При межзонном поглощении света электрон из валентной зоны переходит в зону проводимости, а в валентной зоне образуется дырка. Если переход осуществляется не на самом краю фундам. поглощения, то электрон и дырка быстро (за время $\sim 10^{-12}$ – 10^{-13} с) отдают избыток энергии и импульс фононам и оказываются соответственно на две зоны проводимости и сверху валентной зоны. При рекомбинации они испускают квант света, близкий по величине энергии запрещенной зоны, — возникает т. н. краевая люминесценция. Образование свободных электронов и дырок приводит к фотопроводимости кристалла, спектр возбуждения к-рой наряду со спектрами поглощения и люминесценции позволяет изучать структуру энергетич. зон кристалла (см. *Фотоэлектрическая спектроскопия*).

Кроме процессов рождения и рекомбинации свободных пар электронов и дырок в кристалле могут происходить процессы образования электронно-дырочных пар, связанных кулоновскими силами, — экситонов. Естественно, энергия образования экситона на величину энергии кулоновского взаимодействия меньше, чем энергия образования свободных электронов и дырок, поэтому экситонные полосы поглощения лежат с ДВ-сторонами от полосы фундам. поглощения. Экситон имеет энергетич. спектр, регистрируемый аналогично спектру атома водорода, но вместо массы электрона используют эфф. массу, а также учитывают влияние на электронно-дырочную пару эфф. диэлектрич. проницаемости, создаваемой атомами кристалла. Энергия ионизации экситона (т. е. расстояние в спектре от края фундам. поглощения) $\sim 10^{-2}$ эВ в кристаллах типа A_nB_2 и ~ 1 эВ для щелочно-галогидных кристаллов. Борсовский радиус экситона по величине равен неск. постоянным решеткам для щелочно-галогидных кристаллов и неск. десяткам постоянных решеткам для кристаллов A_nB_2 или кристаллов элементов IV группы Ga, Si (экситоны большого радиуса, или Ванье — Мотта экситоны). В молекулярных кристаллах экситон можно рассматривать как возбуждение отд. молекулы, к-рое индукционно-резонансным путем может мигрировать по кристаллу (экситоны малого радиуса, или Френкеля экситоны).

При комнатной темп-ре экситонные полосы уширены до величин $\sim 10^2$ см $^{-1}$ вследствие колебаний атомов кристалла. При понижении темп-ры в экситонных спектрах проявляется структура, связанная с бесфононными переходами и переходами с участием конечного числа оптич. фононов. Бесфононные линии могут описываться водородоподобную структуру спектра экситонов Ванье — Мотта, структуру, связанную со строением подзон и с т. н. *дальновидским расщеплением* в спектрах экситонов Френкеля.

В экситонах с большим дипольным моментом, возбуждаемых резонансным эл.-магн. полем, невозможно разделить поле на кулоновскую и поперечную составляющие, и их необходимо рассматривать вместе с полем как особую часть — световиктон, или *поляритон*. Эти

возбуждения создают в спектре полосы, являющиеся ДВ-продолжением экситонных полос. Переходами в электронной подсистеме кристалла обусловлено также поглощение при возбуждении поверхностных волн (т. н. поверхностных поляритонов). Поглощение, связанное с этими квазичастицами, не может наблюдаться методами классич. абсорбционной спектроскопии, т. к. прямое поглощение фотона поверхностным поляритоном запрещено законами сохранения энергии и импульса. Возбуждение поверхностных поляритонов осуществляется либо методом *нарушенного полного внутреннего отражения*, либо при отражении света от поверхности кристалла, на к-рой имеется периодич. структура. Полосы поверхностных поляритонов расположены с ДВ-сторонами от соответствующих обычных возбуждений, и их спектральное положение в соответствии с кривой дисперсии зависит от угла падения световой волны и периода поверхностной структуры.

С электронной подсистемой связано поглощение при внутризонных переходах в полупроводниках, проявляющихся в виде широких слабоструктуриров. полос в ИК-области спектра. Поглощение и рассеяние света в кристаллах, обладающих упорядоченной спиновой подрешеткой (напр., ферромагнетиках), могут проявиться в возбуждении магн. дипольного момента (*магноны, спиновые волны*).

Наряду с переходами между уровнями в электронной подсистеме всего кристалла, в спектрах кристаллов проявляются переходы между локальными уровнями дефектов кристаллич. структуры (дефекты кристаллич. структуры осн. вещества или атомы примесей). Дефекты образуют в кристаллах центры поглощения (*центры окраски*) и *центры люминесценции*. Примером простейшего центра окраски в щелочно-галогидных кристаллах являются F -центры, представляющие собой анионную вакансию, захватившую электрон. Система уровней такого центра аналогична системе уровней атома водорода, только смещенной в ДВ-область и уширенной вследствие взаимодействия с колебаниями атомов кристаллич. структуры. Напр., в кристаллах LiF F -центры дают полосу поглощения с длиной волны $\lambda_{\text{макс}} = 248$ нм. При увеличении концентрации F -центров в спектре поглощения проявляются агрегатные F_2 -центры, напр. F_2 -центры, состоящие из двух F -центров в соседних узлах решетки и плавящие переходы, аналогичные переходам в молекуле водорода. В LiF F_2 -центры дают полосы поглощения с длиной волны $\lambda_{\text{макс}} = 445$ нм. Аналогично в спектрах поглощения и люминесценции проявляются полосы, связанные с F_3^- , F_4^- , F_5^- -центрами и т. д.

Уровни энергии внутри запрещенной зоны образуют также примеси, к-рые могут участвовать как в поглощении, так и в люминесценции. Если переходы в атомах примеси происходят во внешних электронных оболочках, то полосы оказываются сильно уширенными в результате взаимодействия атомов с фононами решетки, как и полосы, принадлежащие центрам окраски и молекулярным примесям в органич. кристаллах. При понижении темп-ры в спектрах проявляются бесфононные линии и фононные кр. д. о. расположенные в спектре поглощения — в осн. с ДВ-сторонами от бесфононной линии и с ДВ-сторонами в спектрах испускания. Бесфононные линии в спектрах поглощения и испускания совпадают, а фононные крылья зеркально симметричны (см. *Степанова универсальное соотношение*). Фононные крылья в низкотемпературных спектрах обусловлены взаимодействием электронов с акустич. фононами. Отношение интенсивности бесфононной линии к интенсивности в фононном крыле определяется т. н. *Дебая — Уоллера фактором*, зависящим от константы электрон-фононного взаимодействия. Примеси, создающие широкие интенсивные полосы поглощения в видимой области, приводят к изменению видимой окраски кристалла, напр. у драгоценных камней. Так,

кристалл лейкосафитра Al_2O_3 не имеет полос поглощения в видимой области спектра и прозрачен; введение в него примесей Fe^{2+} и Ti^{4+} приводит к поглощению излучения в красной области спектра, и кристалл приобретает зеленый цвет (изумруд), а введение примесей Cr^{3+} создаст полосы поглощения в синей и зеленой областях спектра, и кристалл приобретает красный цвет (рубин).

Если электронные переходы происходят в хорошо экранированных внутр. оболочках примесных атомов (напр., в атомах переходных и редкоземельных элементов), то константы электрон-фононного взаимодействия и соответственно ширины полос оказываются малыми. Так, полосы поглощения центров окраски и обычных примесных центров имеет ширину $\sim 10^3$ см $^{-1}$ (при комнатной темп-ре). Линии поглощения в спектрах примесных редкоземельных ионов составляют ~ 10 см $^{-1}$. Эти переходы, как правило, осуществляются между уровнями одной конфигурации, расщепленными внутрикристаллич. полем. При понижении темп-ры эти линии сужаются до ширины, определяемой неоднородным уширением, т. е. до долей см $^{-1}$. Уширение, обусловленное электрон-фононным взаимодействием, однородно, время т. н. поперечной релаксации $\sim 10^{-12}$ — 10^{-13} с. Неоднородное уширение связано с неоднородностью кристалла, с изотопной примесью и т. д.

Симметрия кристаллич. поля определяет выделенные направления дипольного момента переходов, к-рые проявляются в различии степени поляризации люминесценции кристаллов и коэффициентов поглощения света, подлриазованного вдоль и перпендикулярно оптич. оси кристалла. Напр., в кристалле рубина решетка Al_2O_3 представляет собой октаэдр, слегка деформированный вдоль пространственной диагонали, к-рая в этом случае является оптич. осью. Деформация приводит к тому, что поглощение света, падающего вдоль оптич. оси, в полосе 5500 Å оказывается в 2 раза больше, а в полосе 4000 Å на 10% меньше, чем распространяющегося в перпендикулярном направлении. Изучение поляризац. характеристик С. н. позволяет определять симметрию решетк, пространственную структуру центров и ориентацию дипольных моментов, соответствующих электронным переходам центров, находящихся во внутрикристаллич. поле.

Проявление фононной подсистемы рассматривалось выше только как фактор, определяющий уширение спектральных полос электронных переходов, или как источник линий фононных повторений электронных переходов, сопровождаемых поглощением или рождением оптич. фононов. Если при возбуждении фононов наводится дипольный момент, то эти колебания проявляются в спектрах ИК-поглощения (оптич. ветви). Колебания, меняющие поляризуемость, проявляются в спектрах комбинац. рассеяния. В кристаллах, обладающих центром инверсии, существует т. н. альтернативный запрет — одно и то же колебание может проявиться либо в ИК-спектре, либо в спектре комбинац. рассеяния света. По законам сохранения энергии и импульса в спектре поглощения проявляется не вся ветвь оптич. колебаний решетки, а узкий интервал вокруг критич. частоты. Если при поглощении света рождается один оптич. фотон, то частоты ИК-полос лежат в дальней ИК-области. В молекулярных кристаллах частоты колебаний соответствуют внутримолекулярным колебаниям и имеют частоты от ~ 3500 см $^{-1}$ и ниже, т. е. полосы поглощения расположены в области от 2,7 мкм и ниже. Кроме того, имеются более слабые полосы, соответствующие возбуждению двух или более фононов или возбуждению нек. фононов одной частоты, полосы поглощения к-рых лежат в ближней ИК-области.

В спектрах комбинац. рассеяния света отражаются как оптич. ветви, колебания к-рых модулируют поляризуемость среды, так и акустич. ветви. Спектры комбинац. рассеяния дают информацию как о спектре оптич.

колебаний решетки, так и о плотности энергетич. состояний на акустич. ветвях колебаний (в этом случае говорят не о комбинационном, а о *Манделштама* — *Бриллюэна* рассеянии света и *Рамановом* рассеянии света). Из-за альтернативного запрета в спектрах комбинац. рассеяния 1-го порядка проявляются типы колебаний, к-рые отсутствуют в ИК-спектрах поглощения, поэтому они дополняют друг друга.

В области радиочастот лежат переходы между уровнями сверхтонкого расщепления, возникающего в результате *Штарка эффекта*. Напр., осн. состояние хрома в рубине имеет расщепление $0,38$ см $^{-1}$ = $1,14 \cdot 10^{10}$ Гц. Обычно переходы между уровнями сверхтонкого расщепления — магнитно-дипольные. При введении кристалла в магн. поле появляются зеемановское расщепление уровней энергии, к-рое наблюдается как при оптич. переходах между зеемановскими подуровнями разл. электронных состояний, так и в радиочастотной области при переходах между зеемановскими подуровнями одного состояния. В этом случае исследование проводят методом *электронного парамагнитного резонанса*. Таким методом изучают кристаллы, содержащие примеси с отличными от нуля магн. моментом в осн. состоянии (парамагн. примеси). Исследование С. к. дает информацию о структуре кристаллич. решетк, уровнях энергии и процессах релаксации энергии в кристаллах, характере нарушенной решетки, примесях и центрах, ими образованных. Изучение спектров фононов необходимо для выяснения механизма сверхпроводимости и создания новых высокотемпературных сверхпроводников. Строение электронных спектров необходимо знать для создания полупроводников, люминофоров, лазерных устройств и т. д. Большинство твердотельных центров (кроме стокл с примесями) созданы на основе изучения электронных переходов в кристаллах.

С. к. проявляются не только в оптич. диапазоне длин волн. В диапазоне γ -излучения кристаллич. структура выявляется только в том, что импульсы отдачи ядер при испускании γ -кванта может восприниматься всем кристаллом, в результате чего наблюдаются сверхузкие несмещенные резонансные линии испускания и поглощения γ -квантов (*Мессбауэра эффект*). Поглощение γ -излучения кристаллами может приводить к образованию дефектов (центров окраски), к-рые проявляются в спектрах др. диапазонов длин волн.

При взаимодействии рентг. излучения с кристаллами возникает его дифракция на атомах кристаллич. структуры, к-рая лежит в основе *рентгеновского структурного анализа*. *Рентгеновские спектры* испускания и поглощения характеризуют структуру внутр. уровней энергии электронов атомов, входящих в кристалл, и практически не зависят от его свойств как коллективного образования атомов.

Лит.: Левши в В. Л. Фотолюминесценция жидких и твердых веществ, М.—Л., 1951; Мосеев С. Т. Описание свойства полупроводников, пер. с англ., М., 1961; Паян С. Д., Элементарные возбуждения в твердых телах, пер. с англ., М., 1965; Агратович В. М., Теория акустиков, М., 1966; Котель Ч., Введение в физику твердого тела, [пер. с англ.], М., 1978; Физика и спектроскопия лазерных кристаллов, М., 1986.

СПЕКТРЫ ОПТИЧЕСКИЕ — спектры эл.-магн. излучения в ИК-, видимом и УФ-диапазонах шкалы *электромагнитных волн*. С. о. разделяют на С. испускания и поглощения (наз. также спектрами излучения или эмиссионными спектрами), С. поглощения и а(б-сorption) и т. п. С. о. получают от источников света при различении их излучения по длинам волн λ (светоизлуч. $\nu = c/\lambda$, волновым числам $1/\lambda = \nu/c$, к-рые часто тоже обозначают ν) с помощью *спектральных приборов*. Характеризуются ф-цией $I(\lambda)$ [или $f(\nu)$], описывающей распределение энергии испускаемого света в зависимости от λ [или ν]; при этом энергию рассчитывают на нек-рый интервал $\Delta\lambda$ [или ν]. С. о. поглощения и рассеяния обычно получают при прохождении света через

вещество с последующим его разложением по λ . С. о. поглощения, рассеяния и отражения характеризуются долей энергии света каждой длины волны, соответственной поглощённой $[k(\lambda)]$, рассеянной $[\alpha(\lambda)]$ или отражённой $[R(\lambda)]$ веществу. При рассеянии монохроматич. света длины волны λ молекулами может происходить комбинационное рассеяние света, спектр к-рого характеризуется распределением энергии рассеянного света по изменённым (комбинационным) длинам волн.

С. о. регистрируют с помощью фоторегистра, методов, фотоэлектрич. приёмники излучения, термоэлементами и болометрами (в ИК-области) и т. д. В видимой области С. о. можно наблюдать визуально.

По виду С. о. могут быть линейчатыми, состоящими из отд. спектральных линий с определ. дискретными значениями λ , полосатыми, состоящими из отд. полос, каждая из к-рых охватывает нек-рый интервал λ , и сплошными (непрерывными), охватывающими широкий диапазон λ . (Строго говоря, спектральная линия всегда имеет нек-рую конечную ширину, характеризующую нек-рым интервалом λ ; см. *Ширина спектральной линии*.)

С. о. возникают при квантовых переходах между уровнями энергии атомов, молекул, твёрдых и жидких тел. С. о. искусственная соответствуют возможным квантовым переходам с верхних возбуждённых уровней энергии на нижние, С. о. поглощения — с нижних уровней на верхние.

Вид С. о. зависит от состояния вещества. Если при заданной тем-ре вещество находится в состоянии термодинамич. равновесия с излучением (см. *Тепловое излучение*), оно испускает сплошной спектр, распределение энергии в к-ром по λ (или ν) даёт *Планка закон излучения*. Обычно термодинамич. равновесие излучения с веществом отсутствует и С. о. могут иметь самый различный вид. В частности, для атомов характерны линейчатые С. о., возникающие при квантовых переходах между электронными уровнями энергии (см. *Атомные спектры*); для простейших молекул типичны полосатые спектры, возникающие при переходах между электронными, колеб. и вращат. уровнями энергии (см. *Молекулярные спектры*).

Разл. оптич. диапазоны λ (или ν) соответствуют разл. энергиям фотонов $h\nu = h\nu_0 - \epsilon$ (ϵ_1 и ϵ_2) — энергии уровней, между к-рыми происходит переход. В табл. приведены для трёх диапазонов длины волн примерные интервалы λ , ν , волновых чисел ν/c , энергий фотонов $h\nu$, а также тем-р излучения T , характеризующих энергию фотонов согласно соотношению $h\nu = kT$ — $h\nu$.

С. о. применяются для исследования строения и состава вещества (см. *Спектроскопия*, *Спектральный анализ*).

Лит.: Лангвельберг Г. С., *Оптика*, 5 изд., М., 1976; Фриш С. О., *Оптические спектры атомов*, М., 1963.

М. А. Ельцинцев.



Примеры спермагнитных структур.

ных системах класса «редкоземельный металл (с ненулевым орбитальным моментом атомов) — ферромагн. металл группы железа», напр. Nd—Co, Nd—Fe, Dy—Co, Dy—Fe [2]. В случае хим. неэвализности магн. атомов спермагнитная структура тождественна аспермагнитной.

Лит.: 1) Соуе J. M. D., *Amorphous magnetic order*, *Adv. Appl. Phys.*, 1978, v. 49, № 3, p. 1846; 2) Таулоу Р. С. и др., *Magnetic properties of amorphous neodymium-transition-metal films*, *Adv. Appl. Phys.*, 1978, v. 49, № 5, p. 2865.

М. В. Мельведев.

СПЕРОМАГНЕТИЗМ (от греч. *σπρίθι* — рассеивая, разбрасывая) — магн. состояние аморфных магнетиков, в к-ром равновесные ориентации локализов. магнитных моментов распределены в пространстве хаотически (суммарная намагниченность отсутствует) и корреляция между ориентациями близлежащих атомных магн. моментов исчезает на интервале неск. межатомных расстояний [1]. Осн. микроскопич. причиной возникновения С. является существование хаотической одноионной магнитной анизотропии типа «лёгкая ось» с энергией $D\Sigma(\mu_B S_z)^2$ (где $D > 0$ [2 и 3]), к-рая в случае относительно малого значения параметра обменного взаимодействия ($J > 0$ или $J < 0$, $D/|J| \geq 1$) вынуждает эфф. моменты S_i подстраиваться к хаотически распределённым локальным осям лёгкого намагничивания μ_i . Такой механизм характерен для металлч. стёкол типа «редкоземельный металл (с ненулевым орбитальным моментом ионов) — благородный или переходный металл», напр. аморфные системы типа Dy—Cu, Tb—Ag. По своей магнитной атомной структуре и осн. особенностям магн. свойств спермагнетики — частный случай сплюснутых стёкол. Термин «сплюснутые стёкла» чаще относят к магнетикам, в к-рых величина и знак обменного взаимодействия меняются случайным образом, в силу чего атомные магн. моменты в них ориентированы хаотически.

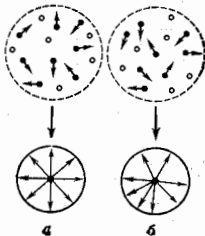
В случае нарушения сферич. симметрии распределения случайных ориентаций магн. моментов возникает состояние, называемое аспермагнетизмом (сокращение от «асимметричный спермагнетизм»), с ненулевой намагниченностью, т. к. большая часть атом-

Диапазон	λ , мкм	ν , с ⁻¹	ν/c , см ⁻¹	$h\nu$, эВ	T, К
ИК-излучение	$10^4-0,74$	$3,0 \cdot 10^{14}-4,0 \cdot 10^{14}$	$10-1,35 \cdot 10^4$	$1,25 \cdot 10^{-4}-1,7$	$14-2,0 \cdot 10^4$
Видимое излучение . . .	$0,74-0,40$	$4,0 \cdot 10^{14}-7,5 \cdot 10^{14}$	$1,35 \cdot 10^4-2,5 \cdot 10^4$	$1,7-3,1$	$2,0 \cdot 10^4-3,8 \cdot 10^4$
УФ-излучение	$0,40-10^{-8}$	$7,5 \cdot 10^{14}-3,0 \cdot 10^{16}$	$2,5 \cdot 10^4-10^6$	$3,1-125$	$3,8 \cdot 10^4-1,4 \cdot 10^6$

СПЕРОМАГНЕТИЗМ (от греч. *σπρίθι* — рассеивая, разбрасывая) — магн. состояние аморфного твёрдого тела с двумя или большим числом хаотических подсистем химически различающихся магн. атомов (ионов), в к-ром по крайней мере одна из подсистем магн. моментов атомов «заморожена» так, что образует аспермагнитную структуру [1] (см. *Спермагнетизм*). Результирующие магн. моменты каждой из подсистем магн. атомов могут быть направлены как параллельно, так и антипараллельно друг другу (рис.), т. е. спермагнетизм является хаотическим нелинейным ферромагнетизмом. С. наблюдается в нек-рых аморф-

ных магн. моментов образует острые углы с направлением намагниченности, а меньшая часть — тупые (рис.). Аспермагнетизм (своеобразный неколлинеарный ферромагнетизм) является состоянием промежуточного типа между состоянием спинового стекла и обычным неколлинеарным ферромагнетизмом. Поэтому он обладает как особенностями спин-стеклового состояния (эффекты магн. вязкости и необратимости магн. изменений из-за наличия многократно вырожденных минимумов свободной энергии, отделённых друг от друга потенц. барьерами), так и дальним ферромагн. порядком [4]. Однако аспермагнетизм является метастабильным состоя-

нием, отодвигаясь вниз, барьером от осн. состояния синь-стеклового типа [5 и 6]. Наличие регулярной пространственной составляющей в магн. анизотропии (к-рая может, напр., возникнуть благодаря механизму магнитоупругой связи с внутр. или внеш. напряжениями, образца) может стабилизировать асперомагнетизм со спонтанно-магнитным дальним ферромагн. порядком. Такая ситуация, по-видимому, реализуется в аморфных сплавах Cd—Ag со слабой хаотич. анизотропией [7].



Схематическое изображение сперомагнитной (а) и асперомагнитной (б) структур.

Если подсистему магн. ионов с асперомагн. структурой рассматривать как своеобразную хаотическую магнитную подрешетку, то такая подрешетка может выступать базовым элементом построения более сложных хаотических магн. структур в неупорядоченных магнетиках с некс. сортами магн. ионов (см. *Сперомагнетизм*) [8].

Лит.: 1) Coey J. M. D., Amorphous magnetic order, *J. Appl. Phys.*, 1978, т. 49, № 3, p. 1648; 2) Harris R. P., Pilschke M., Zuckerman M. J., New model for amorphous magnetism, *Phys. Rev. Lett.*, 1973, т. 31, № 3, p. 180; 3) Coey J. M. D., Harris R. P., Zuckerman M. J., The role of structure in the magnetic properties of amorphous alloys, *Phys. Repts.*, 1978, т. 48, № 1, p. 1; 4) Sellmeyer D. J., Nafis S., Random magnetism in amorphous rare earth alloys, *J. Appl. Phys.*, 1985, т. 57, № 8, p. 3584; 5) Яковлев Ю. А., Бутке Е., Рудник Л., Spin-glass and ferromagnetic behavior induced by random uniaxial anisotropy, *Phys. Rev. Lett.*, 1978, т. 40, № 7, p. 478; 6) Жауарга-Заваб Г., Лидер К., Риск С., Random anisotropy models in the Ising limit, *Phys. Rev.*, 1980, т. 21, № 9, p. 4072; 7) Волголар С. и др., Random anisotropy effects in amorphous rare earth alloys (invited), *J. Appl. Phys.*, 1982, т. 53, № 11, p. 7888; 8) Хейр К. М., Многообразие видов магнитного упорядочения в твердых телах, пер. с англ., «УФН», 1984, т. 142, в. 2, с. 331. М. В. Мовсесов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (частная теория относительности) — физ. теория пространства-времени для областей, в к-рых можно пренебречь полями тяготения и в к-рых могут быть введены локально инерциальные системы отсчета. Подробнее см. *Относительности теория*.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — отдельные классы функций, возникающих во многих теоретич. и прикладных задачах, обычно при решении дифференц. ур-ний. В физике чаще всего встречаются гамма-функции (см. *Эйлера интегралы*), ортогональные полиномы, сферические функции, цилиндрические функции, гипергеометрические функции и вырожденные гипергеометрические функции, параболического цилиндра функции, интегральные синус и косинус, интеграл вероятности (см. *Интегральные функции*), Матье функции, эллиптические функции и др. Все перечисленные ф-ции, за исключением гамма-функции, ф-ций Матье и эллиптических, являются решениями обыкновенного дифференц. ур-ния 2-го порядка:

$$u'' + \frac{\tilde{\tau}(z)}{\sigma(z)} u' + \frac{\tilde{\sigma}(z)}{\sigma^2(z)} u = 0, \quad (1)$$

где $\sigma(z)$, $\tilde{\sigma}(z)$ — полиномы, степень к-рых не выше 2, $\tilde{\tau}(z)$ — полином, степень к-рого не выше 1, z — комплексная переменная.

Напр., ур-ние Бесселя

$$z^2 u'' + zu' + (z^2 - \nu^2) u = 0$$

является частным случаем ур-ния (1) при $\sigma(z) = z$, $\tilde{\tau}(z) = 1$, $\tilde{\sigma}(z) = z^2 - \nu^2$. С помощью замены $u =$

$= \varphi(z)u$ и выбора ф-ции $\varphi(z)$ ур-ние (1) можно привести к виду:

$$\sigma(z)u'' + (\tau(z)u' + \lambda u) = 0 \quad (2)$$

[$\tau(z)$ — полином, степень к-рого не выше 1, λ — постоянная]. При

$$\lambda = \lambda_n = -n\tau' - n(n-1)\sigma''/2, \quad n=0, 1, \dots \quad (3)$$

ур-ние (2) имеет полиномиальные решения, определяемые ф-лой Родрига:

$$y = y_n(z) = \frac{B_n}{\rho(z)} \frac{d^n}{dz^n} [\sigma^n(z)\rho(z)] \quad (4)$$

[B_n — нормировочная постоянная, n — степень полинома, ф-ция $\rho(z)$ удовлетворяет ур-нию $(\sigma\rho)' = \tau\rho$, к-рые после линейной замены переменной переходят в классич. ортогональные полиномы (полиномы Якоби, Лагера и Эрмита).

Ур-ние (2) в зависимости от степени полинома $\sigma(z)$ можно привести к следующим канонич. видам:

$$z(1-z)u'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z]u' - \alpha\beta u = 0$$

(гипергеометрическое уравнение Гаусса),

$$zy'' + (\gamma - z)u' - \alpha u = 0$$

(вырожденное гипергеометрическое уравнение),

$$y'' - 2zy' + 2\nu y = 0$$

(уравнение Эрмита).

Обобщая ф-лу Родрига (4), можно получить в явном виде частные решения ур-ния (2) при произвольных λ в виде интегрального представления

$$y = y_\lambda(z) = \frac{C_\lambda}{\rho(z)} \int \frac{\sigma^\lambda(\xi)\rho(\xi)}{(z-\xi)^{\lambda+1}} d\xi, \quad (5)$$

где величина λ связана с λ соотношением, аналогичным соотношению (3):

$$\lambda + \nu\tau' + \nu(\nu-1)\sigma''/2 = 0,$$

ф-ция $\rho(z)$ — решение ур-ния

$$[\sigma(z)\rho(z)]' = \tau(z)\rho(z),$$

контур C — отрезок прямой (s_1, s_2), на концах к-рого выполнено условие:

$$\frac{\sigma^{\lambda+1}(s)\rho(s)}{(s-z)^{\lambda+1}} \Big|_{s=s_1, s_2} = 0.$$

Контуры такого вида можно выбрать лишь при нек-рых ограничениях, наложенных на коэф. ур-ния (2). Распространение результатов, полученных при таких ограничениях, на более общо случаи можно получить с помощью аналитич. продолжения решений. Из интегрального представления (5) легко вывести все свойства перечисленных С. ф.: разложения в степенные ряды, разл. функциональные соотношения, асимптотич. разложения и др.

При помощи аналогичных рассуждений можно построить теорию разностных аналогов С. ф., в частности классич. ортогональных полиномов дискретной переменной на равномерных и неравномерных сетках.

С. ф. возникают обычно при разделении переменных и отыскании собств. ф-ций дифференц. оператора в нек-рых системах координат. Такие операторы часто инвариантны относительно к.-л. группы преобразований, к-рые переводят собств. ф-ции оператора в собств. ф-ции, отвечающие тому же собств. значению. Т. о., каждому

элементу группы ставится в соответствие линейное преобразование в пространстве соств. ф-ций, наз. *представлением группы*. Поэтому существует связь между С. ф. и матричными элементами представлений групп. Используя свойства представлений, можно получить разл. ф-лы для С. ф., напр. ф-лы сложения, интегральные представления, рекуррентные ф-лы.

Так, представления группы вращения евклидовой плоскости связаны с цилиндрич. ф-циями, представления группы вращений углоподобных матриц 2-го порядка — с гипергеом. ф-циями. Особенно часто в физике используют представления группы вращений трехмерного пространства, с ними связаны *Вигнера функции*, *Клебана — Гордана* и *коэффициенты Вигнера* $6j$ -символов, к-рые можно выразить через ортогональные полиномы первого или второго аргумента. Напр., ф-ция Вигнера удаётся записать с помощью полинома Якоби или полинома Крауча. Коэф. Клебана — Гордана и $6j$ -символов Вигнера можно выразить через полиномы Хаана и полиномы Гака.

Лит.: Бейтман Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. Пер. с англ., 2 изд., т. 2. М., 1973—74; Вилевский И. Я. Специальные функции и теория представлений групп, 2 изд., М., 1991; Никитов А. Ф., Уваров В. В. Специальные функции математической физики, 2 изд., М., 1981. Справочник по специальным функциям, пер. с англ., М., 1979. А. Ф. Никитов.

СПИН (от англ. spin — вращаться, вертеться) — собственный момент количества движения элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого. С. наз. также соств. момент кол-ва движения атомного ядра или атома; в этом случае С. определяется как векторная сумма (вычисленная по правилам сложения моментов в квантовой механике) С. элементарных частиц, образующих систему, и орбитальных моментов этих частиц, обусловленных их движением внутри системы.

С. измеряется в единицах \hbar и равен $J\hbar$, где J — характерное для каждого сорта частиц целое (в т. ч. нулевое) или полуцелое положит. число — т. н. *спиновое квантовое число*, к-рое обычно называют просто С.; в связи с этим говорят о целом или полуцелом С. частицы. Полуцелым С. обладают, напр., электроны, протоны, нейтроны и их античастицы. С. π - и K -мезонов равен нулю, С. фотона равен 1.

Проекция С. на любое фиксиров. направление z в пространстве может принимать значения $-J, -J+1, \dots, +J$. Т. о., частица со С. J_2 может находиться в $2J+1$ спиновых состояниях (при $J = 1/2$ — в двух состояниях), что эквивалентно наличию у неё дополнит. внутр. степени свободы. Квадрат вектора С., согласно квантовой механике, равен $\hbar^2 J(J+1)$. Со С. частицы, обладающей ненулевой массой покоя, связан спиновый магн. момент $\mu = \gamma\hbar$; коэф. γ наз. *магнитомеханическим отношением* (или *гиромагнитным*) отношением.

Концепция С. введена в физику в 1925 Дж. Уленбеком (G. Uhlenbeck) и С. Гаудсмитом (S. Goudsmit), предложившими (на основе анализа спектроскопич. данных), что электрон можно рассматривать как «вращающийся волчок» (отсюда и термин «С.») с соств. механич. моментом $1/2$ и собственным (спиновым) магн. моментом, равным магнетону Бора $\mu_B = \hbar e/2mc$ (е и m — заряд и масса электрона). Т. о., для С. электрона гиромагн. отношение $\gamma = e/mc$, т. е. в точки зрения классич. электродинамики является аномальным: для орбитального движения электрона и для любого движения классич. системы заряд. частиц с данным отношением e/m оно в 2 раза меньше ($e/2mc$).

Учёт С. электрона позволил В. Паули (W. Pauli) сформулировать принцип запрета, утверждавший, что в произвольной физ. системе не может быть двух электронов, находящихся в одном и том же квантовом состоянии (см. *Паули принцип*). Наличие у электрона С., равного $1/2$, объяснило мультиплетную структуру атомных спектров (*тонкую структуру*), особенности

расщепления спектральных линий в магн. полях (*Зеемана эффект*), порядок заполнения электронных оболочек в многоэлектронных атомах (а следовательно, и закономерности периодич. системы элементов), ферромагнетизм и др. явления.

Существование у протона С., равного $1/2$, постулировано на основе опытных данных Д. М. Деннисоном (D. M. Dennison, 1927). Эксперим. проверка этой гипотезы привела к открытию *сверткнутой структуры* уровней энергии атома.

С. частой однозначно связан с характером статистики, к-рой они подчиняются. Как показал Паули (1940), из квантовой теории поля следует, что все частицы с целым С. подчиняются *Бозе — Эйнштейна статистике* (являются бозонами), с полуцелым С. — *Ферми — Дирака статистике* (фермионам). Для фермионов (напр. электронов) справедлив принцип Паули, для бозонов он не имеет силы.

В матем. аппарат нерелятивистской квантовой механики С. был введен Паули; при этом описание С. носило феноменологич. характер. Наличие у электрона С. и спинового магн. момента непосредственно вытекало из релятивистского *Дирака уравнения* (к-рое для электрона в эл.-магн. поле в пределе малых скоростей переходит в *Паули уравнение* для нерелятивистской частицы со С. $1/2$).

Величина С. определяет трансформ. свойства полей, описывающих эти частицы. При *Лоренца преобразованиях* поле, соответствующее частице со С. $J = 0$, преобразуется как скаляр (или псевдоскаляр); поле, описывающее частицу с $J = 1/2$, — как спинор, с $J = 1$ — как вектор (или псевдовектор) и т. д.

Лит.: см. при ст. *Квантовая механика*, О. И. Завьялов. **СПИНОВАЯ ДИФФУЗИЯ** — процесс пространственного выравнивания неоднородной спиновой поляризации в системе локализов. магн. моментов. В отличие от обычной диффузии, связанной с массопереносом, при С. д. распространяется лишь спиновое возмущение, тогда как сами носители спиновых моментов (парамагн. ионы, радикалы, атомные ядра) не перемещаются.

При помехении парамагн. вещества, содержащего частицы с несомкнутыми спинами S , во внеш. магн. поле H возникает отличная от нуля s и n в а. п. о. л. я. р. и з. а. ц. л. $P = \langle S_z \rangle / S$, где $\langle S_z \rangle$ — ср. значение проекции спинового S_z на направление поля (ось Z). В условиях термодинамич. равновесия при темп-ре T_0 поляризация определяется *Больцмана распределением* парамагн. частиц по энергетич. уровням, возникающим вследствие квантования S_z (см. *Зеемана эффект*). В простейшем случае $S = 1/2$ возможны всего две ориентации спина: вдоль и против поля H ; при этом $P = \tanh(\hbar H/2kT_0)$, где γ — *магнитомеханическое отношение*. При нарушении равновесия между спиновой системой и «решёткой» (термостатом) величина P определяется *спиновой температурой* $T_S \neq T_0$. Процессы С. д. возникают в тех случаях, когда пространственное распределение величин P оказывается неоднородным, т. е. $\text{grad } P \neq 0$. Передача избытка поляризации между соседними парамагн. частицами происходит в направлении выравнивания T_S за счёт магн. *диполь-дипольного взаимодействия* или *спин-спинового обменного взаимодействия*. Элементарный акт этого процесса состоит в одноврем. изменении ориентации спинов двух частиц в противоположных направлениях при сохранении их суммарной проекции S_z и суммарной магн. энергии в поле H . Такой акт носит резонансный характер и эффективен лишь при близости частот магн. резонанса взаимодействующих частиц.

Усреднённое макроскопич. описание этого процесса в ряде простейших случаев приводит к обычному у-н.н. диффузии для величин $P(r, t)$, где r — пространственная координата, t — время.

Роль С. д. наиб. существенна в ядерных спиновых системах твёрдых тел, где она обычно определяется магн. диполь-дипольным взаимодействием между соседними

драмы. В этом случае коэф. $S. d. D \approx 0,1 \text{Å}^2/\text{а.е.}$, где a — расстояние между ближайшими ядерными спинами. С. д. значительно ускоряет процессы спин-решётной релаксации и динамич. поляризация ядер, обеспечивая перенос неравновесной спиновой поляризации к примесным парамагн. центрам, осуществляющим передачу энергии ядерных спинов в решётку (см. Реаксация магнитная, Сверхзаера эффект).

В магнитоорядоченных электронных парамагнетиках С. д. осложнена нерегулярным расположением примесных парамагн. центров и значительным неоднородным уширением линий электронного парамагнитного резонанса. В таких системах С. д. может сопровождаться т. н. спектральной диффузией — распространением спинового возбуждения по спектру магн. резонанса.

Явления, сходные со С. д., характерны также для миграции оптич. возбуждения в люминесцентных средах, в частности в активных материалах лазеров.

Лит.: Худинский Г. Р., Спировая диффузия, «ФОН», 1965, т. 87, с. 211; 1968, т. 96, с. 441; Ацаркин В. А., Динамическая поляризация ядер в твёрдых диэлектриках, М., 1960; Абрагам А., Ядерный магнетизм, пер. с англ., М., 1963; Алексеев И. В., Теория магнитной релаксации. Релаксация в жидкостях и твёрдых немагнитных парамагнетиках, М., 1975. В. А. Ацаркин.

С. д. в магнитоупорядоченных веществах, теоретически рассмотрена Л. Ван Ховом (L. Van Hove, 1954) и П. Ж. де Женон (P. G. de Gennes, 1958) и наблюдалась экспериментально с помощью магн. рассеяния нейтронов, является, как и в парамагнетиках, одним из механизмов, определяющих динамику спиновой плотности $S(r,t)$ или намагничённости $M(r,t)$.

В отличие от парамагнетиков, в магнитоупорядоченных веществах значение энергии обменного взаимодействия значительно больше энергии зеемановского взаимодействия. Поэтому неоднородное и неравновесное распределение намагничённости вызывается главным образом не внеш. полем, а коррелированными спиновыми флуктуациями.

Ниже критич. темп-ры T_c (напр., Кюри точка для ферромагнетика или Неема точка для антиферромагнетика) динамика намагничённости носит преимущественно не диффузионный, а волновой характер (см. Спиновые волны). Однако в условиях сильного затухания и малого времени жизни магнонов (T близко к T_c) волновая динамика намагничённости сменяется диффузионной, что проявляется, в частности, в виде т. н. центрального (квазиупругого) пика в спектри критич. магн. рассеяния нейтронов. Выше критич. темп-ры T_c С. д. становится основным механизмом пространственного выравнивания неоднородной намагничённости. Особенности С. д. в парамагнитной области ($T > T_c$) магнитоупорядоченных веществ по сравнению со С. д. в обычных парамагнетиках проявляются в критическом замедлении (аномальное возрастание близки T_c времени магнитной релаксации). Аналогичными свойствами обладают и др. кинетич. и резонансные характеристики (напр., затухание ультразвука в магнетиках, ширина линии ЭПР и др.).

Лит.: Форестер П., Гидродинамические флуктуации, нарушенная симметрия и корреляционные функции, пер. с англ., М., 1960. Ю. Г. Рубой.

СПИНОВАЯ СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ — совокупность явлений, связанных с существованием бездиссипативного механизма переноса намагничённости в сверхтекучем ^3He . При переходе в сверхтекучее состояние атомы ^3He образуют конденсат из куперовских пар в состоянии с полным спином $S = 1$ (см. Гелий жидкий, Сверхтекучесть). Поэтому параметр порядка ^3He содержит угл. переменные φ , описывающие ориентацию системы спинов куперовских пар. Энергия системы не зависит ни от фазы волн φ -ки конденсата, ни от этих угл. переменных. Такое вырождение состояний в случае возникновения градиента к-л. из углов φ приводит к появлению спинового сверхтока $I(M_i) \approx \varphi \varphi$, где M_i — ком-

понента намагничённости $i = x, y, z$. Спиновый сверхток в сверхтекучем ^3He представляет собой встречное гидродинамич. течение двух взаимопровинкающих сверхтекучих жидкостей с противоположно направленными спинами куперовских пар, но сопровождающееся переносом массы.

С. с. была обнаружена в экспериментах по ЯМР в сверхтекучем $^3\text{He}-\text{B}$ (А. С. Боровик-Романов, Ю. М. Буньков, В. В. Дмитриев, Ю. М. Мухарский, 1984—88) и теоретически исследована в работах И. А. Фомина (1984—88). В условиях ЯМР в качестве параметра порядка в $^3\text{He}-\text{B}$ удобно выбрать матрицу трёхмерных вращений R_{ik} , параметризуемую тремя углами Эйлера α, β, γ . Если внеш. поле H направлено вдоль оси z , то углы α и β определяют направление прецессирующей намагничённости M , а угол γ — вращение спиновой системы вокруг M . Угол β между M и H определяет величину проекции намагничённости M_z , а угол α — фазу прецессии M вокруг H . Система вырождена по углу α , к-рым можно рассматривать как фазу параметра порядка.

Экспериментально сверхтекучий ток проекции намагничённости M_z наблюдался как вдоль приложенного поля H , когда градиент фазы создавался за счёт продольного градиента поля, так и перпендикулярно H по капилляру, соединявшему две эксперим. камеры, в к-рых ЯМР возбуждался от независимых генераторов на одной частоте, но с разными фазами.

Возможность эксперим. наблюдения С. с. методом ЯМР в $^3\text{He}-\text{B}$ связана с наблюдаемой в нём характерной особенностью зависимости частоты ЯМР ω от угла β : при $0 \leq \beta \leq \beta_0 = \arccos(-1/2)$ частота ω не зависит от β , а при $\beta > \beta_0$ начинает резко расти. Эта особенность и существование С. с. приводит к тому, что при возбуждении ЯМР радиочастотным полем с частотой в объёме $^3\text{He}-\text{B}$, помещённом в неоднородное магн. поле, этот объём разбивается на два домена: в области сильного поля ($H > \omega/\gamma$, γ — гиромагнитное отношение) прецессия не возбуждается вовсе и $\beta = 0$, в поле $H \leq \omega/\gamma$ возбуждается прецессия на общей частоте ω и с общей фазой прецессии α , определяемой генератором. При этом на границе между доменами угол $\beta = \beta_0$ и нарастает в области более слабого поля, называемой *домом рождения прецессии* и *рущим домом*.

Для С. с. имеет место весь комплекс явлений, характерных для обычной сверхтекучести: четвёртый звук, ограничение величин сверхтекучего переноса намагничённости — критич. спиновый ток с образованием центров проскальзывания фазы, стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона, квантование циркуляции сверхтекучей скорости и образование квантованных спиновых вихрей. В отличие от обычной сверхтекучести и сверхпроводимости, где фаза конденсата ненаблюдаема, фаза прецессии наблюдаема. Поэтому удаётся измерить разность фаз на концах канала, сброс фазы при одном акте проскальзывания, а также точную локализацию центра проскальзывания фазы и распределение фазы по каналу.

В отличие от обычной сверхтекучести, в $^3\text{He}-\text{B}$ наряду с бездиссипативным переносом намагничённости, возникающим вследствие образования когерентного состояния, при наличии градиентов углов α и β обязательно присутствуют и диффузионные диссипативные спиновые потоки. Спиновая диффузия, а также др. механизмы диссипации приводят к несохранению параллельной полю компоненты намагничённости, что соответствовало бы несохранению массы сверхтекучей компоненты в ^3He или несохранению заряда в сверхпроводниках.

Явление С. с. возможно не только в сверхтекучем $^3\text{He}-\text{B}$, но и в антиферромагнетиках, релятивистские взаимодействия в к-рых сохраняют вырождение по отнosit. фазе прецессии намагничённости подрешёток.

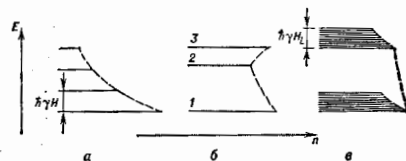
Лит.: Фомин И. А., Стационарный спиновый сверхтон в ^4He -В, «ЖЭТФ», 1988, т. 94, с. 112; Fomin I. A., Spin currents in superfluid ^4He , «Physica B», 1991, v. 169, p. 153; Богович К. Р. и др., А. С. и др., NMR and magnetic supercurrent in ^4He -В, «Physica Scripta», 1991, v. T39, p. 136. А. С. Вороних-Романов, В. П. Мичеев.

СПИНОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — термодинамик. величина, характеризующая состояние внутр. квазиравновесия в подсистеме спиновых степеней свободы вещества. Наиб. распространение понятие С. т. получило при описании электронных и ядерных парамагнетиков. В этом случае С. т. T_s определяет вероятность W_i нахождения системы частиц, обладающих спином, в стационарном состоянии с энергией ϵ_i :

$$W_i = Z^{-1} \exp(-\epsilon_i/kT_s), \quad (1)$$

где Z — статистич. сумма. Соотношение (1) аналогично обычному каноническому распределению Гиббса, однако ϵ_i — лишь часть полной энергии системы, зависящая от спиновых переменных. Предполагается, что локально внутр. равновесие в спиновой подсистеме (квазиравновесие) устанавливается гораздо быстрее, чем равновесие между спиновой подсистемой и остальными степенями свободы (истинное равновесие с темп-рой T_0).

Примером может служить система ядер, обладающих спином $I \neq 0$ и гиромагн. отношением γ , в твёрдом теле, помещённом во внеш. пост. магн. поле H . Взаимодействие магн. момента ядра с этим полем приводит к образованию $2I + 1$ уровней энергии ϵ_j , разделённых равными интервалами $\hbar\gamma H$ и соответствующих разл. значениям проекции I_z ядерного спина на направление H (рис., а). Внутр. квазиравновесие в этой системе устанавливается благодаря спин-спиновым



энергетические диаграммы в квазиравновесном распределении населённости парамагнитных спиновых системы в магнитном поле: а — $I = 1/2$, спиновый температур; б — различные спиновые температуры в квазиравновесном спектре; в — асимметрия в «спин-спиновой» спиновой температуре; ϵ — энергия, n — населённость; пунктир соответствует распределению Больцмана.

взаимодействиям между ядрами: 1) создаваемые ядерными магн. моментами локальные поля приводят к расфокусировке протессы спинов в поле H за время τ по сравнению с релаксацией τ_1 , в результате сохраняется макроскопич. характеристической системы остаётся ср. значение I_z ; 2) взаимные «перевороты» ядерных спинов, вызванные спин-спиновым взаимодействием, приводят к «завыванию» их нач. распределения по состояниям также за время $\sim \tau_1$. Поэтому на интервалах времени $t \gg \tau_1$ можно считать спиновую подсистему квазиравновесной. Обычно $\tau_1 \sim 10^{-8} - 10^{-4}$ с оказываются много меньше времени спин-решёточной релаксации $\tau_1 \sim 10^{-2} - 10^3$ с.

Распределение (1) сводится при этом к Больцмановскому распределению населённости n_j по уровням ϵ_j :

$$n_j/n_k = \exp(-(\epsilon_k - \epsilon_j)/kT_s). \quad (2)$$

Если спиновая система не подвергается внеш. воздействия, она приходит в равновесие с решёткой, играющей роль термостата; при этом $T_s = T_0$. Однако при воздействии резонансного радиочастотного магн. поля с частотой $\omega = \gamma H$, индуцирующего квантовые переходы между соседними магн. уровнями [см. Ядерный

магнитный резонанс (ЯМР)], населённости уровней постепенно выравниваются, что в соответствии с (2) означает повышение С. т. В пределе $n_j/n_k \rightarrow 1$ и $T_s \rightarrow \infty$ (насыщение ЯМР).

Понятие С. т. обобщается также на системы с разл. расстояниями между соседними уровнями энергии, что типично для электронного парамагнитного резонанса, ядерного квадрупольного резонанса и др. В этом случае отсутствие резонанса между разл. переходами спектра препятствует установлению квазиравновесия с единой С. т. T_s . Однако каждой паре уровней j, k можно приписать, следуя (2), свою «парциальную» С. т. T_{jk} .

При насыщении к-л. перехода (напр., 1 \rightarrow 3 на рис., б) населённости этих уровней выравниваются и соответствующая С. т. $T_{13} \rightarrow \infty$, тогда как на др. переходах С. т. может оказаться как выше, так и ниже T_0 или стать отрицательной (см. Отрицательная температура). Последнее означает, в соответствии с (2), что населённая верх. уровня больше, чем нижнего (см. уровни 3, 2 на рис., б). Возможность состояний с отрицательной С. т. характерна для систем (не только спиновой природы), спектр энергии к-рых ограничен сверху. Такие состояния способны к вынужденному излучению эл.-магн. поля, с ними связана работа квантовых генераторов и усилителей (см. также Лазер).

Термодинамический смысл С. т. более полно проявляется в твёрдых парамагнетиках при учёте энергии спин-спиновых взаимодействий. При этом каждый уровень ϵ_j расщепляется в квазиравновесную полосу шириной $\sim \hbar\gamma H_L$, где H_L — ср. локальное поле. При $H \gg H_L$ квазиравновесие в такой системе описывается двумя С. т.: «внешнемагнитной» T_{ext} и «спин-спиновой» T_{ss} . Они характеризуют соответственно распределение населённости по уровням ϵ_j и внутри непрерывных полос (рис., в).

Адиабатич. уменьшение поля H за время $t < \tau_1$ приводит к понижению С. т. В частности, при адиабатич. размагничивании до $H = 0$ получается $T_s = -T_0 H_L/H$. Адиабатич. размагничивание электронных и ядерных парамагнетиков используется для магнитного охлаждения до темп-р ниже 1 К.

В магнитоупорядоченных веществах (ферро- и антиферромагнетиках) аналогом С. т. является эфф. темп-ра подсистемы магнов (см. Релаксация магнитная).

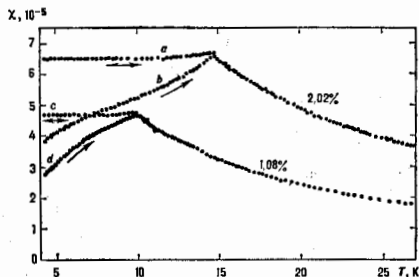
Лит.: Гольдман М., Спиновая температура в ЯМР в твёрдых телах, пер. с англ., М., 1972; Ацаркин В. А., Родик М. И., Температура спин-спиновых взаимодействий в электронном парамагнитном резонансе, «УФН», 1972, т. 107, с. 3; Абрахам А., Гольдман М., Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок, пер. с англ., т. 1-2, М., 1984.

В. А. Ацаркин.

СПИНОВОЕ КВАНТОВОЕ ЧИСЛО — квантовое число, определяющее величину силы квантовой системы (атома, яона, атомного ядра, молекулы), т. е. её свойств. (внутр.) момента кол-ва движения (момента импульса). Спиновый момент импульса s квантуется: его квадрат определяется выражением $s^2 = \hbar^2 s(s+1)$, где $s = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, \dots$ (называемое часто просто спином). Проекция вектора s на произвольное направление z также квантуется: для частиц с ненулевой массой $s_z = \hbar m_s$ (где m_s — магнитное спиновое число), т. е. принимает $2s+1$ значений. Число s может принимать целые, нулевые или полуцелые значения.

СПИНОВОЕ СТЕКЛО — магнетик, в к-ром ниже определённой темп-ры (темп-ра замораживания T_f) возникает термодинамик. неравновесное метастабильное магн. состояние (также паа. С. с.), к-рое характеризуется «замороженными» (отсутствуют термодинамич. флуктуации) пространств. распределением ориентаций спиновых магн. моментов. Состояние С. с. вызывается, как правило, наличием в системе хаотическ. расположенных магн. моментов, конкурирующих (т. е. имеющих разл. знаки, величину и пространственную зависимость) взаимодействий и обусловленной ими фрустрацией магн. моментов (см. ниже), поэтому состояние С. с. обычно возникает в неупорядоченных или аморфных

магнетика. Выше T_c С. с. переходит в равновесное магн. фаза (напр., парамагнитную). У любых веществ в состоянии С. с. существует ближний магн. порядок; дальний магн. порядок может реализовываться (см. *Спермагнетизм, Спермагнетизм*) или отсутствовать (см. *Спермагнетизм*). Неравновесность состояния С. с.



Температурная зависимость $\chi(T)$ статической магнитной восприимчивости сплава Cu—Mn для 1,08 и 2,02 атмных % Mn. Участки а и б получены в поле $5,9 \cdot 10^{-4}$ Тл, которые было приложено и образцам выше T_c ещё до их охлаждения. Участки в и д были получены после охлаждения образцов ниже T_c без магнитного поля и последующим повышением температуры в поле $5,9 \cdot 10^{-4}$ Тл.

определяет зависимость его физ. параметров от времени, магн. и термич. предистории (как физ., так и технол.) данного образца, а также от степени однородности, хим. чистоты и др. Всё это резко осложняет получение воспроизводимых эксперим. результатов. Для С. с. характерны макроскопич. необратимые эффекты, в т. ч. *магнитная вязкость, магнитное старение, гистерезис магнитный* и обусловленные ими явления магн. последствия и памяти.

Характерными признаками магнитного фазового перехода в состояние С. с. в пост. внеш. магн. поле H являются: возникновение при $T > T_c$ и малых H намагниченности m и её рост при понижении темп-ры вплоть до T_c ; наличие при $T = T_c$ резкого излома (быстро сглаживающегося с ростом H) статич. магн. восприимчивости $\chi = \Delta M / \Delta H$ (рис. 1), линейный ход магн. составляющей теплоёмкости C при низких T и отсутствие особенностей C при $T = T_c$; отсутствие брагговских пиков в магнитном рассеянии нейтронов, критич. замедление спиновой диффузии и др. При наблюдении перехода в фаза С. с. в переменном внеш. магн. поле с частотой ω обнаруживается ряд необычных для др. магн. фаз явлений: частотная зависимость (дисперсия) темп-ры замерзания T_c , появление мнимой части динамич. восприимчивости $\chi''(\omega)$, наличие долговременной (логарифмич.) релаксации *магнитной* и N -Ч-шумов.

Состояние С. с. наблюдалось ещё с нач. 60-х гг. в разбавленных бинарных металлах, сплавах и твёрдых растворах A_2B_{2-x} , содержащих магн. ионы в немагн. матрице (А — магн. ион переходного металла Mn, Fe; В — немагн. ион благородного металла Au, Ag или ионы в определённом интервале концентраций x ; однако термин «С. с.» возник лишь после детальных работ В. Каннолли и Дж. Мидола (V. Cannolla, J. Mydosh, 1972). Характерные для С. с. эксперим. результаты были получены на магн. диэлектрике $Eu_2Sr_{1-x}S$ при $0,13 \leq x \leq 0,84$ (при $x < 0,13$ в образце возникает *суперпарамагнетизм*, а при $x > 0,84$ — *ферромагнетизм*), на ряде бинарных и тройных систем, напр. на интерметаллах, сплавах переходных металлов друг с другом (Fe—Ni) и с редкоземельными металлами (La—Tb), редкоземельных сплавах типа Y—Tb, (Fe—Cd), редкоземельных, полупроводниках HgTe или CdTe,

легированных Mn и др. Типичные магн. фазовые диаграммы в состоянии С. с. см. на рис. 5—8 в *Магнитный фазовый переход*.

К проявляющимся в этих веществах конкурирующим взаимодействиям, влияющим на установление разл. видов магн. упорядочения, относятся: *объемное взаимодействие* и *косвенное объемное взаимодействие* ферро- и антиферромагн. характера; зависящее от взаимной ориентации магн. моментов *диполь-дипольное взаимодействие*; осциллирующее *РКК-объемное взаимодействие*. В регулярных кристаллич. структурах такие взаимодействия могут приводить к появлению сложной неколлинеарной *магнитной атомной структуры* (в т. ч. несоизмеримой). В нерегулярных твердотельных системах (аморфных веществах, неупорядоченных двух- или многокомпонентных сплавах и твёрдых растворах) благодаря конкуренции и хаотич. взаимному расположению магн. и примесных ионов (вызывающих иногда случайное изменение локальной осн. магн. анизотропии) возникает *фрустрация* магн. моментов, приводящая к образованию состояния С. с. В этом случае для расчёта наблюдаемых физ. величин кроме обычного термодинамич. усреднения по ансамблю систем с *Гиббса распределением* вероятности (обозначаемого (...)) необходимо дополнит. усреднение (обозначаемое чертой сверху) по всем возможным реализациям хаотич. расположения магн. моментов или набора взаимодействий между ними; при этом в качестве ф-ции распределения обычно выбирается комбинация дельта-функций или *Гаусса распределение*. Полное (но математически сложное) решение задачи усреднения по случайным конфигурациям для свободной энергии С. с. даёт т. н. метод реплик (от франц. *replique* — копия, образ).

В отличие от обычных магнитоупорядоченных фаз, в С. с. фрустрированных осн. состояние имеет в пространств. конфигурации магн. моментов не один глобальный минимум энергии (или при наличии вырождения небольшое их число, ведущее к появлению *магнитной доменной структуры*), а макроскопич. большое (растущее экспоненциально с ростом числа магн. моментов N) число локальных минимумов (до l и n , обладающих иерархической (у л-т n метрической) структурой). Система магн. моментов С. с. испытывает случайную диффузию в пространств. долиах, преодолевая потенциальные барьеры разл. высоты (в пределе больших N сколь угодно высокие). Этим объясняется практически непрерывный широкий диапазон времён магн. релаксации (по теоретич. оценкам, от 10^{-12} до 10^{10} с). В С. с. при $T = T_c$ благодаря фрустрации происходит переход системы магн. моментов в специфическое («замороженное») состояние, характеризующееся спонтанным нарушением *эргодичности*, — подобно тому, как обычный фазовый переход связан со спонтанным нарушением соотв. симметрии (см. *Параметр порядка*). Практически неэргодичность означает, что любое измерение магн. характеристики С. с. при конечных временах наблюдения описывает фаз. свойства С. с. лишь в квазиравновесном состоянии, соотв. пребыванию системы магн. моментов в одной или нескольких (по заданному во всех) долиах α с вероятностями P_α .

Обобщённым параметром порядка для С. с. может служить случайная ф-ция распределения локальной намагниченности $m_i = \langle S_i \rangle \neq 0$ в узле i (в случае многих долиах — ф-ция m_i^α). Обычно ограничиваются двумя её низшими моментами: ср. значением $m = (1/N) \sum_i m_i =$

$$= (1/N) \sum_\alpha P_\alpha \sum_i m_i^\alpha$$

$$= (1/N) \sum_\alpha P_\alpha P_\alpha m_i^{\alpha 2}$$

$$= (1/N) \sum_{\alpha\beta} P_\alpha P_\beta m_i^{\alpha\beta}$$

Термодинамически сопряжённым параметром для q является дисперсия σ^2 локального ввсп. магн. поля h , причём статич. реакция функция $\chi = \partial q / \partial \sigma^2$, выражающаяся через нелинейную восприимчивость $\chi^2 = \partial m_i / \partial h^2$, имеет расходимость при $T = T_f$.

В случае, когда $m = 0$ (идеальное С. с.), вместо q вводятся два параметра порядка q_1 и q_2 , описывающие анизотропию (С. с. в случае кластерного или миктомагнитного см. Миктомагнетизм) С. с. в качестве параметров порядка используются набор коррелл. ф-ций $\langle m_i m_j \rangle$, характеризующих ближний магн. порядок. Применяются и др. определ. параметра порядка, существенно опирающиеся на неэргодичность С. с., напр. «однодолинного» типа $q' = \lim_{t \rightarrow \infty} \langle m_i(0) m_i(t) \rangle = (1/N) \sum_p \sum_i \langle m_i^2 \rangle$

[параметр Эдвардса — Андерсона (S. F. Edwards, P. W. Anderson), 1975], а также «двухдолинного»

типа $q_{ab} = (1/N) \sum_i m_i^a m_i^b$ [параметр Паризи

(G. Parisi), 1983], учитывающий перекрытие (корреляцию) двух долин α и β .

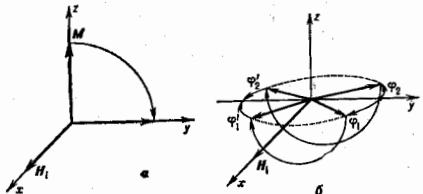
Теснотч. описание свойств С. с. весьма далеко от завершения, несмотря на значит. число аналитич. и компьютерных расчётов. Термодинам. свойства С. с. изучены достаточно хорошо в рамках модели Шеррингтона — Киркпатрика [ШК-модель (D. Sherrington, S. Kirkpatrick), 1975], представляющей собой *среднее поле приближение для Ишига* модом с дальнедействием. Обменный интеграл в этой модели не зависит от расстояния и является гауссовой случайной величиной с ненулевым ср. значением. В рамках ШК-модели дётся качественно правильное при малых N описание поведения $\chi(T)$, $m(T)$ и $q(T)$. Де Альмейда и Д. Таулес (De Almeida, D. Thouless, 1978) установили границы устойчивости решения ШК-модели [линия $T(N) \sim N^{1/2}$ в фазовой плоскости (N, T)]; Паризи (G. Parisi, 1980) усовершенствовал метод реплик, учти переходы между долинами, и получил решение, пригодное во всей плоскости (T, N) . Существует много обобщений ШК-модели на случай учёта разл. типов анизотропии, размерности решетки или параметра порядка, а также радиуса взаимодействия; при этом широко используются Ландау теория и метод *ренормализационной группы*. Динамич. свойства С. с. получили теоретич. описание как в рамках традиц. подходов стохастич. динамики для индивидуальных спинов, так и с помощью *зависающего от времени континуального интеграла*, позволяющего избежать введения метода реплик.

Состояние С. с. не только проявляет необычные магн. свойства, но и служит хорошей моделью для ряда интересных задач в смежных областях науки, напр. для *локальных каубровых полей* Инга — Миллса в теории элементарных частиц, для векр-ных комбинаторных задач теории графов, теории оптимизации и организации параллельных вычислений в компьютерных сетях. Большой интерес С. с. представляет в связи с введением на его основе моделью действия нейронных сетей при организации везлокальной памяти, устойчивой к дефактам структуры и обладающей точностью и скоростью обработки информации.

Лит.: Херд К. М., Многообразие влпов магнитного беспорядка в твёрдых телах, «УФН», 1984, т. 142, в. 2, с. 231; Коренблит И. Я., Шендер Е. Ф., Спиновые стекла, М., 1984; Методы Монте-Карло в статистической физике, пер. с англ., М., 1982; Кин и пель В., Спиновые стекла как «вазельные системы» для нейронных сетей, «УФН», 1987, т. 152, в. 1, с. 123; Гинзбург С. Л., Неэравные явления в спиновых стеклах, М., 1989; Fischer K. H., Hertz J. A., Spin glasses, Cambridge, 1991; Доценко В. С., «УФН», 1993, т. 148, с. 1.

СПИНОВОЕ ЭХО — явление повторного возникновения сигналов ядерной или электронной магн. индукции, обусловленное фазировкой спиновых магн. моментов

под действием радиочастотных импульсов. Простейший вид С. э. открыт Э. Ханом (E. Hahn) в 1950. Образец, содержащий ядра со спином $I \neq 0$ и гироманг. отношением γ , помещают в пост. магн. поле H и подвергают действию радиочастотных импульсов линейно поляризованного магн. поля $2H_1 \cos \omega t$, удовлетворяющего условиям *ядерного магнитного резонанса* (ЯМР): $H_1 \perp H$; $\omega = \gamma H$. Удобно перейти в систему координат, вращающуюся с частотой ω вокруг оси $z \parallel H$ в ту же сторону, что и ларморовская прецессия ядерных спинов. В этой системе координат циркулярно поляризованная в указанном направлении компонента радиочастотного поля становится статической и определяет направление оси x . Равновесная ядерная намагниченность M , первоначально направленная вдоль H , после включения поля H_1 начинает прецессировать вокруг него с угл. частотой γH_1 и через время $t_1 = \pi / 2\gamma H_1$ оказывается направленной вдоль оси y (рис., а). В этот момент первый импульс РЧ-поля ($\pi/2$ -импульс) выключается.



Спиновое эхо в неоднородном магнитном поле (вращающаяся система координат): а — поворот намагниченности M под действием $\pi/2$ -импульса; б — расфокусировка спинов, имеющих различные частоты прецессии, и их повторная фокусировка после π -импульса.

Последующая прецессия вектора M вокруг H в плоскости xy наводит в приёмной катушке спектрометра ЯМР сигнал с свободной i и дукцией. Со временем этот сигнал затухает (поперечная релаксация), т. к. ядерные спины находятся в разных локальных магн. полях и, как следствие, имеют различающиеся частоты прецессии. Это связано как с неоднородностью ввсп. магн. поля H , так и с внутр. магн. полями, создаваемыми ядрами друг на друге. Эфф. время поперечной релаксации $T_2^* \propto 1/\gamma \Delta H$, где ΔH — ширина линии ЯМР. Если локальные поля постоянны во времени (напр., обусловлены неоднородностью поля H), то прецессия спинов оказывается обратной и возможно наблюдение С. э.

На рис. (б) показаны траектории движения двух ядерных спинов. Угл. частоты их прецессии отличаются от ω на малые величины и равны соответственно $\omega + \delta_1$ и $\omega - \delta_2$, поэтому во вращающейся системе координат они поворачиваются в плоскости xy за время t на углы $\varphi_1 = \delta_1 t$ и $\varphi_2 = -\delta_2 t$ от оси y . Если теперь подать на образец второй радиочастотный импульс, аналогичный первому, но с длительностью $t_2 = 2t_1$ (π -импульс), то спины повернутся вокруг оси x на угол π и займут положения $\varphi = \pi - \varphi_1$ и $\varphi = \pi - \varphi_2$. Двигаясь затем с прежними угл. скоростями и в том же направлении, оба спина спустя время t после второго импульса одновременно достигнут направления $-y$, т. е. произойдёт фазировка ядерных магн. моментов и повторное появление сигнала индукции. Описанный механизм С. э. действует при условии $t_1, t_2 \ll T_2^*$, что эквивалентно требованию $H_1 \gg \Delta H$.

В действительности восстановление сигнала свободной индукции методом С. э. не может быть полным; потери обусловлены зависящими от времени внутр.

локальными полями. Зависимость величин сигнала S э. от времени $2t$ позволяет измерять истинное время поперечной релаксации T_2 . Так же исследуют структуру спектров ЯМР, скрытую неоднородным уширением. Существует разл. модификация описанного варианта S э. Трёхимпульсное S э. делает возможным измерять наряду с T_2 время T_1 продольной релаксации T_1 . Многоимпульсные когерентные методы позволяют на неск. порядков повысить чувствительность и разрешающую способность ЯМР-спектроскопии.

Методы S э. используют также в ядерном *квадрупольном резонансе* и *магнетронном парамагнитном резонансе*, хотя при этом трудно выполнить условие $H_1 \gg \Delta H$. Большим своеобразием отличается S э. в ферромагнетиках и антиферромагнетиках.

Явления, аналогичные S э., характерны и для систем иной природы, обладающих дискретным набором квантовых энергетик. уровней, уширенных статическими случайными полями. Известны, в частности, *фотонное эхо*, *поляризован. эхо*, *фононное эхо* и др.

Лит.: Фаррар Г. Т., Вениер Э., Игульскии и Фурье-спектроскопия ЯМР, пер. с англ., М., 1973; Салихов К. М., Семенов А. Г., Петров Ю. Д., Электронное спиновое эхо и его применение, Новосиб., 1976; Уо Дж., Новые методы ЯМР в твердых телах, пер. с англ., М., 1978. В. А. Азаркин.

СПИНОВОЙ ПЛОТНОСТИ ВОЛНЫ — термодинамически равновесное состояние вещества, характеризующееся пространственно неоднородным периодич. распределением плотности магн. момента $M(r)$. При этом усредненной макроскопич. магн. момент системы равен нулю ($\langle M(r) \rangle = 0$) и S п. в. можно рассматривать как одно из проявлений *антиферромагнетизма*. Пространственное распределение $M(r)$ описывается соотношением:

$$M(r) = M_1 \exp(iQr) + M_1^* \exp(-iQr), \quad (1)$$

где Q — волновой вектор S п. в.

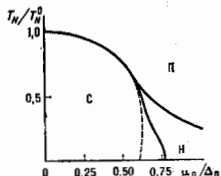
Чаще всего под S п. в. понимают антиферромагнетизм системы взаимодействующих коллективизиров. электронов (см. *Зонный магнетизм*). Парамаг. осн. состояние однородного электронного газа может оказаться неустойчивым относительно образования S п. в. Неустойчивость зависит от характера взаимодействия между электронами. Особенности зонной структуры могут стабилизировать S п. в., т. е. привести к антиферромагн. осн. состоянию электронной системы.

Критерий неустойчивости парамаг. состояния зонного магнетика (см. *Стокера критерий ферромагнетизма*) определяется не только величиной потенциала межэлектронного взаимодействия, но и зависимостью магн. восприимчивости $\chi(q)$ от электронного волнового вектора q . Напр., если в силу к.-л. особенности топологии *ферми-поверхности* $\chi(q)$ обладает резко выраженным максимумом при нек-ром значении $q \neq 0$, то фазовый переход при $T \rightarrow 0$ К из парамаг. состояния в состояние S п. в. может иметь место даже при слабом взаимодействии между электронами. Наличие конзурвентов (совпадающих при трансляции на волновой вектор Q) электронных и дырочных участков на поверхности Ферми (е и s т и г) в веществах с металлич. проводимостью приводит к возможности триплетного электрон-дырочного спаривания с возникновением S п. в.

Наиб. подходящей моделью для микроскопич. описания фазового перехода в состоянии S п. в. является модель *экситонного диэлектрика*. В системах с S п. в. выявляется цель Δ в электронном энергетич. спектре и особенности *плотности состояний* на краях этой щели. С этим связаны особенности оптич., кинетич., магн., упругих и др. свойств S п. в. От краев щели отщепляются спин-поляризов. состояния, отсутствующие в парамаг. фазе и приводящие к резонансным аномалиям кинетич. свойств. Необычно и поведение *дефектов* в окрестности дефекта происходит дополнит. перераспределение спиновой плотности, т. е. формируется ближний антиферромагн. порядок, сохраняющий

ся иногда выше точки Нееля T_N (локализованная S п. в.). На фоне осн. состояния ниже точки Нееля $T < T_N$ в электронном газе формируются своеобразные коллективные возмущения спиновой плотности (амплитудоны, фазоны, С. п. в.-магноны). Теория продвигает также существование слабо затухающих коллективных возмущений выше T_N . С. п. в. образуется в результате фазового перехода (обычно 2-го рода, хотя возможны фазовые превращения 1-го рода) при темп-ре ниже точки Нееля (рис.).

Фазовая диаграмма экситонного диэлектрика для фазового перехода в состояние волны спиновой плотности (2-го рода): П — парамагнитная фаза; С — антиферромагнитная соизмеримая фаза; Н — антиферромагнитная несоизмеримая фаза; $\mu_0 = (\mathcal{F}_1 - \mathcal{F}_2)/2$, Δ_0 соответствует $T = 0$ К, $\mu_0 = 0$, T_N — темп-ра перехода в состояние волны спиновой плотности при $\mu_0 = 0$.



Пространственный период волны может выражаться через целое число постоянных кристаллич. решетки (соизмеримая фаза), но возможно появление и несоизмеримых сверхструктур, т. е. S п. в., период к-рых не кратен периоду кристаллич. решетки.

В переходных металлах и их сплавах реализуется ситуация, когда $Q = G/2$, где G — вектор *обратной решетки*, что соответствует соизмеримой фазе. В более общем случае $Q = (G/2)(1 + \delta)$, где $|\delta| \ll 1$ и зависит от T , что соответствует несоизмеримой фазе.

Стрды чистых металлов, в к-рых наблюдаются S п. в., наиб. исследован Сг, поверхность Ферми к-рого обладает двумя конзурвнтными участками: дырочным октаэдром, центрированным в точке N *Бриллюэна зоны*, и электронным квазиоктаэдром, центрированным в точке Γ . Октаэдрч. грани перпендикулярны к направлению $[111]$, и электронный октаэдр меньше дырочного. Значит, часть этих двух листов поверхности Ферми может быть совмещена трансляцией на волновой вектор $Q = (G/2)(1 + \delta)$, где $\delta \approx 0,05$ при $T = 0$ К. При этом суммарные объемы электронного и дырочного октаэдров примерно равны, и в фазе S п. в. эти октаэдры исчезают, перекрытые целью.

Измерения нейтронной дифракции на монокристаллах Сг показали, что магн. упорядочение в нём существенно отличается от обычного антиферромагнетизма (см. *Магнитная нейтронография*), причём δ имеет слабую температурную зависимость (при $T \sim T_N$ величина $\delta \approx 0,04$). Выше T_N ср. магн. момент на 1 атом Сг порядка $0,1 \mu_B$ в ферромагн. фазе он составляет $0,40 \mu_B$. Темп-ра Нееля чистого Сг ≈ 312 К; при $T < 120$ К поперечная модуляция периодической магн. структуры сменяется на продольную — происходит т. н. *спин-флип переход*.

Теория зонного антиферромагнетизма и S п. а. позволила интерпретировать магн. свойства сплавов Сг. Концентрац. фазовые диаграммы этих сплавов, переход из несоизмеримой структуры в соизмеримую, изменение магн. структуры и свойств под давлением и др. особенности также хорошо описываются моделью окситонного диэлектрика. При этом в сплавах S с немаргнитными переходными металлами изменение состава сплава влияет на T_N и параметры структуры S п. в. Напр., для сплавов с Мо и W влияние примесного рассеяния электронов — единств. причина изменения T_N и параметров структуры. Для сплавов с металлами-донорами (Mn, Re, Os, Rh и др.) с ростом их концентрации происходит выравнивание объёмов электронного и дырочного октаэдров, и при нек-рой концентрации примеси происходит переход из модулированной в чисто удвоенную антиферромагн. структуру. Для металлов-акцепторов (V, Ni) с ростом их концентрации δ

растёт. Зависимость T_N от концентрации примеси для доноров пемонотонная, для акцепторов — падающая.

Выявлены и др. магнитич. системы, в к-рых имеет место переход из парамагн. состояния в состояние С. п. в. К ним относятся редкоземельные металлы и их сплавы с переходными металлами, обладающие геликоидальной антиферромагн. структурой. В этих веществах поверхность Ферми имеет конгруэнтные элементарные участки ($\delta \neq 0$). Примерами таких систем служат Eu и сплавы Y и Se с тяжёлыми редкоземельными металлами (Th, Gd, Dy, Ho). В сплавах Y и Sc с Cr и Ti реализуются синусоидальная антиферромагн. структура, т. е. С. п. в., прохождения к-рой также связано с особенностью поверхности Ферми.

Сплавы и соединения переходных металлов также испытывают переход из парамагн. состояния в состояние С. п. в. К таким системам относятся упорядоченные сплавы FeRh, Pt₂Fe, MnNi, геликоидальные магнетики FeGe₂, MnS₂, соединения CrB₂, слоистые халькогениды — ванадий (V₂S₄, V₂Se₄), возможно, сульфид никеля NiS и *интерметаллические соединения* из группы фаз Лавеса — TiBe₂ и Ti_{1-x}Cu_xBe₉. В т. н. фазе α Маггелли V₇O_{2n+1} при $2 < l \leq 9$ также имеет место переход в фазу С. п. в., причём на фоне *волны зарядовой плотности*. В ряде активных соединений с тяжёлыми фермионами (URuSi₃, UCu₃, UCd₁₁, U₂Zn₇, U_{1-x}Th_xPt₃) С. п. в. формируется при низких температурах в фазе тяжёлой ферми-жидкости. Конкретное применение модели С. п. в. к перечисленным объектам требует учёта дополнит. эффектов — *магнитострикции*, спиновой поляризации остальных участков поверхности Ферми, наличия волны т. н. резонанса Абрикосова — Сула (см. *Промежуточная элементность*).

Особой группой веществ, в к-рых наблюдаются состояния С. п. в., являются некоторые квазиодномерные органические проводники, напр. (TMTSF)_xX — тетраметил-тетраселенфульвален, где X — анионы (X = PF₆, AsF₆). Установлено также существование С. п. в. и в непер. др. анионах. Переходу в антиферромагн. фазу отвечает С. п. в. с удвоенным (по сравнению с постоянной решётки) периодом в продольном направлении. Возможно, что магн. упорядочение в металлооксидах типа La—Sr—Cu—O и Y—Ba—Cu—O также представляет собой С. п. в., что связано с проблемой высокотемпературной сверхпроводимости (см. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*).

В широком смысле понятие С. п. в. может быть обобщено на случай произвольных периодич. сверхструктур в антиферромагнетиках (геликоидальные, синусоидальные структуры). Феноменология, теория магн. сверхструктур основывается на теории фазовых переходов 2-го рода Ландау. В нематаллах формирование сверхструктур происходит под влиянием релятивистских взаимодействий спин — решётка и спин — спин, а также вследствие анизотропного *обменного взаимодействия*. Периоды сверхструктур в антиферромагн. металлах определяются взаимодействием электронов проводимости со спинами магн. ионов и мало отличаются от величин, обратных экстремальным диаметрам поверхности Ферми.

Лит.: Дьяков И. И. Е. Ф., Теория геликоидальной структуры в антиферромагнетиках, *ЖЭТФ*, 1964, т. 48, с. 1420; т. 47, с. 337, 992; Куликов Н. И., Тугушев В. В., Волны спиновой плотности и зонный антиферромагнетизм в металлах, *ЖУФН*, 1984, т. 14, в. 4, с. 643; Горюнов Л. П., Физические явления в новых органических проводниках, там же, в. 3, с. 381; Морья Т., Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами, пер. с англ., М., 1988.

В. В. Турушев, Е. П. Виликин.
СПИНОВЫЕ ВОЛНЫ — волны нарушенной магн. упорядоченности в ферро-, антиферро- и ферримагнетиках. Спины атомов в этих веществах и связанные с ними магн. моменты в этих состояниях упорядочены. Отклонение магн. момента от преимущественного направления не локализуется на атоме, а в виде волны распространяется в среде. С. в. — элементарное возбуждение

магн. системы в магнитоупорядоченной среде; *квазичастицы*, соответствующие С. в. наз. магнотонами. Существование С. в. в *ферромагнетиках* предсказано Ф. Блохом (F. Bloch) в 1930. Вся совокупность внеприм. факторов о поведении магнитоупорядоченных тел при темп-ре T аналитично ниже темп-ры Кюри T_c (или темп-ры Нееля T_N) свидетельствует о существовании С. в. (в частности, *Блоха закон*).

С. в., как всякая волна в кристалле, характеризуется законом дисперсии — зависимостью ω частоты ω от квазилового вектора k . Энергия ϵ к квазиимпульсу p магнтона равна: $\epsilon = \hbar\omega$, $p = \hbar k$. Кристалл с N магнитными подрешётками имеет N типов (ветвей, мод) С. в. с разл. законами дисперсии: $\omega = \omega_l(k)$; $l = 1, 2, \dots, N$.

Классическое описание. С. в. допускают наглядную классич. интерпретацию: рассмотрим цепочку атомов, расстояние между к-рыми a , в магн. поле H . Если вдоль вектор $k = 0$, то все спины синфазно прецессируют вокруг H с частотой ω_0 (одинаковая прецессия). При $k \neq 0$ прецессия спинов неоднородна — разные спины повернуты на разные углы, разность углов поворота равна ka (рис. 1). Частота

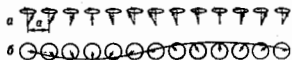


Рис. 1. Спиновая волна в линейной цепочке спинов: а — вид цепочки спинов в перспективе (обозр.); б — вид цепочки спинов сверху; волна изображена линией, проходящей через концы спиновых векторов.

неоднородной прецессии $\omega(k) > \omega_0$. В реальных системах малые колебания магн. моментов атомов осуществляются в виде волн неоднородной прецессии.

В случае длинных волн колебания магн. моментов можно описывать как колебания макроскопич. векторов — плотности магн. моментов (*намагниченностей*) подрешёток $M_i(r, t)$ — ф-ций координаты r и времени t . При неоднородной прецессии длины векторов $|M_i| = \mu_i/\mu_0$, где μ_i — магн. момент атома i -й подрешётки, μ_0 — объём ячейки кристалла, сохраняются; $|M_i|$ — интегралы движения. Законы дисперсии длинноволновых С. в. определяются из *Ландау — Лифшица уравнения*:

$$\frac{\partial M_i}{\partial t} = \gamma [M_i H^i]; \quad H^i = -\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial M_i}. \quad (1)$$

Здесь $\gamma = e/mc$ — *магнитомеханическое отношение* (без учёта спин-орбитальной связи); e , m — заряд и масса электрона, \mathcal{E} — энергия взаимодействия магн. моментов подрешёток, $H_{\text{эф}}$ — эфф. магн. поле (см. ниже). Осн. состояние определяется условием коллинеарности намагниченностей M_i и эфф. магн. полей H^i :

$$\left[M_i H_{\text{эф}}^i \right] = 0. \quad (2)$$

Линеаризация ур-ния (1) с учётом (2) приводит к системе ур-ний для перем. составляющих магн. моментов:

$$m_i = M_i - M_{i0}; \quad m_i \perp M_{i0}. \quad (3)$$

Поле $H_{\text{эф}}$, кроме пост. магн. поля H , содержит перем. часть h — магн. поле, связанное с взаимодействием между подрешётками и с неоднородностью их намагниченностей. Т. к. частоты С. в. невелики, то для определения h можно воспользоваться ур-ниями магнито-статистики:

$$\text{rot } h = 0; \quad \text{div } h = -4\pi \text{ div } m_i; \quad m = \sum_{i=1}^N m_i. \quad (4)$$

Магн. поле h осуществляет магнитодипольное взаимодействие между колеблющимися

магн. моменты. Лягуарова у-рия (1) совместно с (4) суть ур-ния С. в. Представляя в них

$$m_i = m_{i0} \exp[-i(\omega t - kr)], \quad (5)$$

получаем алгебраич. систему ур-ний относительно амплитуд С. в. m_{i0} . Равенство нулю детерминанта этой системы приводит к ур-нию N -го порядка относительно ω^2 . Его решения определяют законы дисперсии С. в. при $ak \ll 1$.

Обычно в магнитоупорядоченных средах гл. роль во взаимодействии между магн. моментами атомов играет *обменное взаимодействие*, изотропное относительно однородного поворота магн. моментов атомов. Магн. порядок появляется в результате *спонтанного нарушения симметрии* обменного взаимодействия. Энергия обменного взаимодействия соседних атомов $|J|$ порядка темп-ры Кюри T_C (темп-ры T_N); знак J выбирается так, что при $J > 0$ обменное взаимодействие благоприятствует фазе ферромагн. упорядоченно, а при $J < 0$ — антиферромагнитоуму.

Ветви спинового волн. Число ветвей С. в. равно числу магн. подрешеток. Это обусловлено прецессионным характером движения магн. моментов подрешеток. Ветви С. в. принято делить на акустические и оптические аналогично колебаниям кристаллической решетки. Если пренебречь малыми (по сравнению с обменными), т. е. релятивистскими, взаимодействиями (зеemannовскими с постоянными магн. полям, спин-орбитальным — источником энергии *магнитной анизотропии*, магнетодипольным и др.), то акустич. ветви С. в. представляют собой *голдстоуновские моды*, т. е. в их энергетич. спектре при $k \rightarrow 0$ щель отсутствует. Частоты акустич. С. в. стремятся к 0 с ростом длины волны $\lambda = 2\pi/k$. Их число и характер закона дисперсии $\omega(k)$ при $k \rightarrow 0$ зависят от структуры осн. состояния магнетика, причём при любом кол-ве подрешеток число акустич. мод ≤ 3 . У однодопреточного ферромагнетика одна акустич. мода с $\omega \propto |J|(ak)^2/h$ при $ak \ll 1$; у двухдопреточного антиферромагнетика 2 вырожденные акустич. моды с $\omega \propto |J|(ak)/h$. В ферромагнетике магнов напоминает нерелятивистскую частицу с энергией $\epsilon = p^2/2m$, в антиферромагнетике — акустич. фонон с $\epsilon = cp$ (m , c — масса частицы и скорость звука). Примеры магнетиков, имеющих 3 акустич. ветви в спектре С. в., — многодопреточные антиферромагнетики с неколлинеарными расположениями магн. моментов в упорядоченном состоянии при $H = 0$ (UO_2 , CsNiCl_2 , CsMnV_2 и др.).

Учёт релятивистских взаимодействий приводит к возникновению энергии щели в спектре акустич. ветвей С. в. $\hbar\omega_0 \neq 0$ (ω_0 — частоты однородной прецессии). Когда в спектре С. в. есть оптич. моды, их частоты однородной прецессии $\omega_0 \sim |J|/h$.

Дисперсия С. в. является причиной зависимости тензора *магнитной восприимчивости* χ от волнового вектора k : $\chi_{ik} = \chi_{ik}(k)$ (см. *Дисперсия протранстенна*). Частотная дисперсия (зависимость χ от ω) является следствием прецессии магн. моментов подрешеток. Тензор χ_{ik} определяется в результате решения ур-ния (1), а *Максвелла уравнения* дают возможность найти связь между ω и k , т. е. законы дисперсии С. в., учитывающие конечность скорости света. При $k \gg \omega/c$ они отличаются от законов дисперсии, полученных на основе ур-ний магнитоэластики (4), малыми поправками, к-рые иногда существенны, напр. при описании взаимодействия С. в. с электронами проводимости в металлах и полупроводниках.

В магнетиках со сложной структурой (антиферромагнетиках и ферритах) изменение темп-ры и ввеш. условий (магн. поля, давления) может привести к переориентации равновесных магн. моментов. При этом произойдет т. н. *ориентационный фазовый переход*, к-рый изменяет спектр С. в. Если это фазовый переход 2-го рода, то он сопровождается обращением в нуль частоты одной из ветвей С. в.

С ростом k ($ak \sim 1$) проявляется дискретная (кристаллич.) структура магнетиков. Для получения законов дисперсии, справедливых при произвольном значении ak , обычно используют приближённые представления спиновых операторов \hat{s}_i через операторы рождения \hat{a}_i^+ и уничтожения \hat{a}_i магнов, подчиняющиеся бозевским правилам коммутации (преобразование Хольштейна — Примакова):

$$\begin{aligned} \hat{s}_i^+ &\approx (2s_i)^{1/2} \hat{a}_i^+, \quad \hat{s}_i^- = \hat{s}_i^x \pm i\hat{s}_i^y; \quad \hat{s}_i^z \approx (2s_i)^{-1/2} \hat{a}_i; \\ \hat{s}_i^z &= s_i - \hat{a}_i^+ \hat{a}_i; \\ \hat{a}_i^+ \hat{a}_m^+ - \hat{a}_m^+ \hat{a}_i^+ &= \delta_{im}. \end{aligned} \quad (6)$$

Здесь индекс i нумерует атомы, координатные оси выбраны так, чтобы ось z для каждого атома была направлена вдоль равновесного положения спина. Из правил коммутации для \hat{a}_i^+ , \hat{a}_i следует, что $n_i = \hat{a}_i^+ \hat{a}_i$ — любое целое число от 0 до ∞ , хотя по физич. смыслу $n_i \leq 2s_i$. Вблизи основного состояния ср. значение n_i значительно меньше s_i , и приближённые ф-лы (6) пригодны для вычисления спектра тем точнее, чем больше s_i (в квантовомеханич. пределе $s_i \gg 1$). Однако и при $s_i \sim 1$ частоты С. в., как правило, лишь небольшими поправками отличаются от значений, найденных с помощью (6).

Магнонный спектр. Теоретич. рассмотрение позволяет вычислить энергию магнов при любом k . Это приводит к периодич. зависимости

$$\omega_i(k+2\pi b) = \omega_i(k), \quad (7)$$

где b — произвольный вектор *обратной решетки*. Так, гамма-точка однодопреточного магнетика

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{i,m} J(R_{im}) \hat{s}_i^+ \hat{s}_m^- - \mu \sum_i \hat{s}_i^z H. \quad (8)$$

Здесь $J(R_{lm})$ — обменный интеграл между l -м и m -м атомами, R_{lm} — вектор, соединяющий эти атомы, μ — магн. момент атома. С помощью (7) и (8) (пренебрегая взаимодействием между магновыми) можно получить спектр магнов:

$$\hbar\omega(k) = 2s \sum_R J(R) \sin^2 \left(\frac{1}{2} kR \right) + \mu H. \quad (9)$$

Ширина магновной энергетич. зоны $\Delta\hbar\omega = \hbar[\omega(k_{\text{макс}}) - \omega(0)]$, где $k_{\text{макс}} = (\pi/2a)b$, равна:

$$\Delta\hbar\omega = 2s \sum_R J(R) \approx 2sJ$$

(J — обменный интеграл для ближайших соседей). Соотношение $\Delta\hbar\omega \propto J$ — общее свойство магновных зон.

Магнитный момент магнона. Зависимость энергии магнона от магн. поля H означает, что магнон обладает магн. моментом:

$$\mu = -\partial\hbar\omega/\partial H. \quad (10)$$

В простейшем случае чисто обменного однодопреточного ферромагнетика магн. момент магнона равен магн. моменту атома и направлен против равновесной намагниченности. Увеличение числа магнов приводит к уменьшению величины спонтанной намагниченности магнетика. В многодопреточных магнетиках рост числа магнов уменьшает намагниченность подрешеток.

В магн. металлах (Fe, Co, Ni и др.), где за магн. свойства ответственны d -электроны, в формировании

спектра С. в. принимает участие нелокализов. электронов проводимости. В длинноволновом пределе ($ak \ll 1$) С. в. в магн. металле — одна из ветвей колебания ферми-жидкости.

Газ магнов. Магноны являются бозонами. При конечной темп-ре $T \neq 0$ магнов. много. Их число N_M пропорц. объёму тела V и растёт с ростом T :

$$N_M \approx \frac{V}{v_0} (T/T_C)^{3/2} \text{ — для ферромагнетиков,}$$

$$N_M \approx \frac{V}{v_0} (T/T_N)^3 \text{ — для антиферромагнетиков.}$$

Мн. свойства магнетиков при $T \ll T_C (T_N)$ удобно описывать, считая, что С. в. представляют собой почти идеальный газ магнов. (см. *Вырожденный газ*). Химический потенциал газа магнов. равен 0, т. к. число магнов. не сохраняется; равновесная ф-ция распределения магнов. по энергиям:

$$\bar{n}_i = \frac{1}{\exp[\omega_i(k)/kT] - 1}. \quad (11)$$

Ф-ла (11) позволяет вычислить температурную зависимость термодинамич. характеристик магнетика (намагниченности, теплоёмкости, магн. восприимчивости и др.). Получающиеся выражения тем точнее, чем идеальнее газ магнов. Неидеальность — результат взаимодействия магнов. друг с другом, с др. квази-частицами (с фононами, электронами). С ростом T число любых квазичастиц растёт, их взаимодействие становится столь существенным, что представление об идеальном газе магнов. перестаёт быть справедливым. Кроме того, может нарушиться условие квазистационарности С. в. $\omega(k) \gg \tau^{-1}(k)$, где τ — время жизни магнона. Поэтому простейшая концепция газа магнов. применима при $T \ll T_C (T_N)$. При этом важную роль играют низкочастотные (релятивистские) магноны; при $T \ll T_C$ их значительно больше, чем обменных (последних экспоненциально мало). Однако учёт изменения спектра магнов. при повышении темп-ры позволяет обобщить концепцию газа магнов. практически на широкий диапазон T , включающий T_C .

Влияние спиновых волн на кинетические свойства магнетиков. С. в. позволяют описать не только термодинамич. (равновесные) свойства магнетиков, но и их кинетические и резонансные свойства. В *тепловодности* магнетиков наряду с фононами и электронами (для проводников) принимают участие магноны: один из механизмов *затухания звука* — рассеяние звуковых волн на магнонах; в магн. металлах и полупроводниках рассеяние электронов на магнонах — один из механизмов электросопротивления; ферро- и антиферромагнитный резонанс можно представить как превращение фотона в магнон, при ферроакустич. резонансе в магнон превращается фонон.

Для описания кинетических и резонансных процессов существенно время жизни магнона $\tau_i(k)$. Среди процессов, определяющих время жизни магнов., выделяются собств. процессы, характерные для идеального кристалла (магнон-магнонные, магнон-фононные и др. взаимодействия), и несобственные (рассеяние магнов. на примесях, дислокациях, границах кристаллитов и поверхности образца).

Взаимодействие магнов. друг с другом и с др. квазичастицами может привести не только к их рассеянию, но и к перестройке их спектра. С возрастанием числа магнов. (N_M) наблюдается нелинейный (по N_M) сдвиг частоты С. в. Учёт сдвгов ф-лы (8), «отброшенных» при получении ф-лы (9), приводит к взаимодействию магнов., носящему характер притяжения. В результате притяжения между магнонами может образоваться своеобразный сининовый комплекс — двухчастичное связанное состояние. В частности, в ферромагнетике, состоящем из атомов со спином $1/2$, возникает возбуждение, соответствующее движению по

кристаллу двух спинов, связанных между собой и перервнутых относительно вектора намагниченности. Как правило, спиновые комплексы образуют магтоны с энергией $\hbar\omega \sim J$ [их роль при $T \ll T_C (T_N)$ явлевана]. Резонанс между С. в. и волной колебания др. природы (напр., звуковой) может привести к «ростагнации» ветвей, что проявляется в существовании гибридных колебаний, напр. магнитоупругих (см. *Магнитоупругие волны, Магнитоупругое взаимодействие*).

Экспериментальные методы. Первыми эксперим. методами исследования С. в. были измерения температурной зависимости термодинамич. характеристик — намагниченности, магн. части *теплоёмкости* (рис. 2, 3).

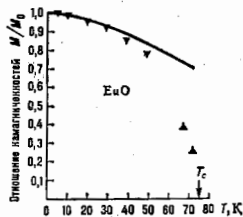


Рис. 2. Температурная зависимость намагниченности ферромагнитного соединения ЕиО. Сплошная кривая — расчёт $M(T)$ по теории спиновых волн.

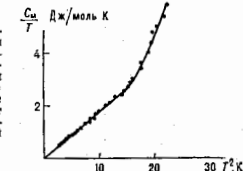


Рис. 3. Температурная зависимость магнитной части теплоёмкости C_M легкоплавного антиферромагнетика $MnSO_4$. При низких температурах $C_M = cT^3$, резкое отклонение от этого закона происходит при $T > 6$ К, соответствующей «включению» второй ветви спектра.

Неупругое рассеяние нейтронов является наиб. информативным методом, позволяющим определить закон дисперсии С. в. и оценить время жизни всех типов магнов. Использование *поляризованных нейтронов*, кроме того, даёт возможность получить сведения о поляризации С. в. Исследованы спектры сотен магнетиков, в т. ч. сложных (рис. 4, 5).

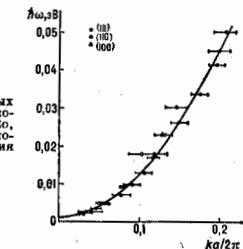


Рис. 4. Спектр спиновых волн ферромагнитного нобельтового сплава (92% Со, 8% Fe), полученных с помощью неупругого рассеяния нейтронов.

Неупругое рассеяние нейтронов не позволяет исследовать спектр С. в. при предельно малых квазидольных векторах k , т. к. в этом случае пик неупругого рассеяния накладывается на пик упругого рассеяния (см. *Магнитная нейтронография*). Ферро- и антиферромагн. резонансы дают возможность измерить значение частот однокордовой прецессии ω_p , т. е. щелей $\hbar_c \omega_p$ в спектре магнов. Для исследования нач. участка спектра ($k \leq 10^8 \text{ см}^{-1}$) используют резонанс на сточках

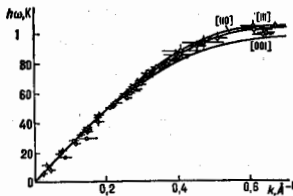


Рис. 5. Спектр спиновых волн в кубическом антиферромагнетике BiMnF_3 , установленный методом неупругого рассеяния нейтронов; кривые — расчёты спектров в предположении, что $|J|/k = 3,4$ К.

С. в. в пластинах, параметр возбуждения С. в. эл. магн. полем, а также неупругое рассеяние света (*Мандельштама - Бриллюэна рассеяние*). Каждый из методов не универсален, но в совокупности они позволяют с большой полнотой определять спектр С. в. многих магнитоупорядоченных кристаллов.

Длинноволновые участки спектра спиновых волн век-рых веществ: 1) одноподрешоточный кубич. ферромагнетик ($N = 1$)

$$\omega^2(k) = \omega_0 + \omega_{\text{обм}}(ak)^2 + \frac{1}{2}\omega_m \sin^2 \theta_k \times \times [\omega_0 + \omega_{\text{обм}}(ak)^2]; \quad (12)$$

$$\omega_0 = \gamma H - \omega_m N_z; \omega_m = 4\pi M; \omega_{\text{обм}} \propto (J/k) > 0.$$

Здесь M — намагниченность насыщения, N_z — размагничивающий фактор, θ_k — угол между намагниченностью M и волновым вектором k С. в. Коэф. $\omega_{\text{обм}}$ характеризует роль обменного взаимодействия магн. атомов, коэф. ω_m — магнитодипольного взаимодействия. Ф-ла (12) описывает такие акустич. ветви С. в. ферромагнетиков, в частности железитривого граната (ЖИГ), у которого 20 подрешоток и со-

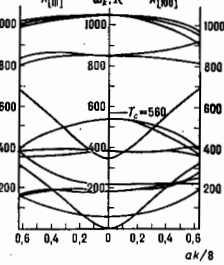


Рис. 6. Теоретический спектр спиновых волн в железитриговом гранате.

ответственно 20 ветвей С. в. (рис. 6). В табл. 1 приведены константы акустич. ветви С. в. ЖИГ:

Табл. 1.

γ, ГГц/кЭ	M, Э	α, А	hω _{обм} , К	T _с , К
2,8	1730	12,5	41	560

Табл. 2.

Вещество	γ, ГГц/кЭ	H _A , кЭ	H _E , вЭ	H _D , кЭ	H _A ² , кЭ ²	α ₁ × 10 ⁴ , кЭ·см ²	α ₁ · 10 ⁴ , кЭ·см ²	T _N , К
SrMnF ₃	2,8	2,48	350	0	$\frac{6,4}{T}$	0,88	0,95	53,5
MnCO ₃	2,8	3,04	320	4,4	$\frac{5,8+0,3}{T}$	0,79	0,61	32,5
FeVO ₄	2,8	5,3	3·10 ⁴	100	$\frac{4,9}{T}$	7,8	5,67	348

В ЖИГ наиб. исследованы процессы релаксации С. в. В чистых монокристаллах теоретич. значения времени жизни релятивистских магновов согласуются с экспериментом. При комнатной темп-ре (300 К) $\tau^{-1} \approx 2,6 \cdot 10^6$ с⁻¹ при $k \rightarrow 0$.

2) Двухподрешоточные одноосные антиферромагнетики с магнитной анизотропией типа «лёгкая плоскость» имеют 2 акустич. ветви С. в. (H параллельно лёгкой плоскости):

$$\omega_1^2 = \gamma^2 [H(H + H_A) + H_A^2 + \alpha_1^2 k_1^2 + \alpha_1^2 k_1^2],$$

$$\omega_2^2 = \gamma^2 [2H_A H_E + H_D(H + H_A) + \alpha_1^2 k_1^2 + \alpha_1^2 k_1^2]. \quad (13)$$

Здесь H_A, H_E — поля анизотропии и обмена, H_D — т. н. поле Дзялошинского, описывающее силу, приводящую к слабому ферромагнетизму, H_E — слабое поле, определяемое слабыми взаимодействиями (сверхтонким, магнитоугром), α₁, α₁ — константы неоднородного обмена (α₁ — вдоль оси симметрии кристалла, α₁ — перпендикулярно к оси; табл. 2).

3) Двухподрешоточные антиферромагнетики с магн. анизотропией типа «лёгкая ось» имеют 2 акустич. ветви С. в., вырожденных при H = 0:

$$\omega_{1,2} = \gamma \left[(2H_A H_E + \alpha_1^2 k_1^2 + \alpha_1^2 k_1^2)^{1/2} \pm H \right]; H \leq \sqrt{2H_E H_A}$$

(H параллельно «лёгкой оси»). Величина щели при H = 0 $\omega_{10} = \omega_{20} = \gamma \sqrt{2H_A H_E}$ для большинства исследованных легкососных антиферромагнетиков лежит в диапазоне 100 — 1000 ГГц.

С. в. в низкоразмерных системах, в кристаллах с большой энергией магнитной анизотропии, в поликристаллах. В двумерных и одномерных системах, описываемых моделью Гейзенберга, С. в. нельзя трактовать как малое колебание, т. к. даже при T = T_с магн. упорядочение не наступает (в согласии с Мермина - Ванера теоремой). В подобных магнетиках при T = T_с возникает бесцелые возбуждения — С. в., у которых скорость (если ω ∝ k) или эфф. масса (если ω ∝ k²) служит осн. характеристикой, отличающей низкотемпературную фазу (T < T_с) от высокотемпературной (T > T_с).

В век-рых кристаллах (напр., CsCoCl₃, FeF₂) энергия магн. анизотропии не мала по сравнению с обменной энергией. При этом структура осн. состояния и спектр С. в. зависит от конкретного соотношения между обменной энергией и энергией анизотропии. Характерная особенность — сложная зависимость магн. характеристик от магн. поля, перестройка осн. состояния под действием магн. поля.

Длинноволновые С. в. (ak < 1) сохраняют смысл в поликристаллах. Дополнительное (по сравнению с монокристаллами) затухание С. в. связано с рассеянием на границах кристаллов.

Спиновые волны в парамагнитных металлах и газах. В парамагнитных металлах С. в. предсказаны В. П. Сидниным в 1960, обнаружены экспериментально в 1967. В немагн. металлах С. в. — колебания спиновой плотности электронов проводимости, обусловленные обменным

взаимодействием между ними. С. в. в немагн. металлах проявляются, напр., в селективной прозрачности металл. пластин для эл.-магн. волн с частотами, близкими частоте электронного парамагн. резонанса.

В классическом (невыврожденном) газе частиц, обладающих спинами, наряду с упругими волнами за счёт обменного взаимодействия между атомами могут распространяться своеобразные волны, также называемые спиновыми. Они предсказаны в 1981, обнаружены в атомарном водорододе из He в 1984.

Лит.: А. Квееер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетинский С. В., Спиновые волны. М., 1967; Воиновский С. В., Магнетизм. М., 1971; Уайт Р., Квазичастицы в магнетиках, пер. с англ., 2 изд., М., 1985; Косовича А. С., Ильясов В. А., Ковалева А. С., Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны, К., 1983; Львов В. С., Нелинейные спиновые волны, М., 1987; см. также лит. к ст. Ферромагнетизм, Антиферромагнетизм, М. И. Казанов, Л. А. Прохорова.

СПИНОВЫЕ ФЛУКТУАЦИИ — отклонения локального значения спиновой плотности от её ср. значения. В случае некоррелированных С. ф. их вклад в термодинам. свойства — пренеор. N^{ν} (где N — число частиц в системе) и исчезает в *термодинамическом пределе*. Возбуждения спиновой подсистемы можно рассматривать как коррелированные С. ф. К. С. ф. такого рода относятся магнотон, более сложные спиновые возбуждения, существующие в магнитоупорядоченных фазах при темп-рах, близких к критич., а также спиновые возбуждения в парамагн. фазе. Состояния *спинового стека* или состояния со *спиновой плотностью волной* можно интерпретировать как ансамбль замороженных или статич. С. ф.

Наиболее полное описание свойств С. ф. в магнетиках дал Т. Мория (Т. Moriya). В рамках предложенной им теории С. ф. удалось развить единый подход к описанию свойств магнетиков с локализованными и дelokализованными (коллективизированными) носителями магн. моментов. Теория С. ф. основана на использовании преобразования Стратоновича — Хаббарда для Хаббарда модели, к-рое позволяет заменить систему взаимодействующих спинов на систему невазимодействующих спинов, находящихся в фактивных флуктуирующих магн. полях. С помощью такого подхода удаётся построить классификацию магн. веществ по характеру С. ф. в них. В веществах с локализованными магн. моментами С. ф. являются преимущественно поперечными (т. е. локальный магн. момент может поворачиваться по направлению при постоянной амплитуде). В слабых зонах магнетика (см. *Зонный магнетизм*, *Стонера модель*), напротив, преобладают продольные С. ф. (т. е. изменяется амплитуда локального момента).

В теории С. ф. получено общее выражение для темп-ры Кюри (для ферромагнетиков) и Нееля (для антиферромагнетиков), а также рассчитана магн. восприимчивость веществ с произвольным характером С. ф. При этом существуют два механизма возникновения температурной зависимости типа *Кюри — Веиса закона* для магн. восприимчивости. Для веществ с локализованными магн. моментами возникновение такой температурной зависимости магн. восприимчивости обусловлено постоянством амплитуды локальных магн. моментов и описывается в рамках *Гейзенберга модели*. Для зонах магнетиков средневекторчатая амплитуда С. ф. $\Delta S^2 = (S^2 - \langle S^2 \rangle^2)$ близки критич. темп-ры линейно зависят от темп-ры. Это приводит к тому, что зависимость магн. восприимчивости от темп-ры также приобретает вид закона Кюри — Веиса, но константа Кюри в этом случае обратно пропорц. параметру продольной жёсткости С. ф., характеризующему степень изменения амплитуды локального момента во флуктуирующем магн. поле.

Важным достижением теории С. ф. является введение представления о температурно-индуцированных локальных магн. моментах в зонах магнетика. Благодаря тому, что амплитуда С. ф. возрастает с ростом

темп-ры и при нек-рой темп-ре T^* достигает макс. значения, С. ф. в зонах магнетиках при темп-рах выше T^* приобретают такой же характер, что и С. ф. в веществах с локализованными магн. моментами, для к-рых амплитуда С. ф. фиксирована при любой темп-ре. Поэтому поведение магн. свойств зонах магнетиков при темп-рах выше T^* выглядит так, будто в системе существуют температурно-индуцированные локализованные магн. моменты.

Лит.: Moriya T., Takahashi J., Spin fluctuation theory of itinerant electron ferromagnetism. A unified picture, *J. Phys. Soc. Jap.*, 1978, т. 48, № 2, p. 397; Hubbard J. Calculation of partition functions, *Phys. Rev. Lett.*, 1959, в. 3, № 2, p. 77; Мория Т., Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами, пер. с англ., М., 1983; А. В. Веиса, О. А. Котляшкова, М. Ю. Николаев.

СПИНОВЫЙ ГАМИЛЬТОНИАН — оператор энергии спиновой подсистемы атомов, ионов, молекул и твёрдых тел, выражающийся через операторы *спина* электронов и нуклонов, составляющих эти физ. объекты (см. *Гамильтониан*). Полный С. г. можно разбить на два слагаемых — квазиклассический и обменный С. г. (не имеющий классич. аналога). С. г. широко применяется в физике магн. явлений для описания реал. свойств магнетиков, в т. ч. типов *магнитных атомных структур*, магн. ветвей спектра упорядоченных магн. систем (включая описание *магнитных фазовых переходов*), реал. видов *магнитного резонанса* и т. п. (см. также *Парамагнетизм*).

Для решения широкого круга задач физики конденсиров. состояний помимо магнетизма (напр., сверхтекучести и сверхпроводимости, сегнетоэлектричества, упорядочения сплавов и т. п.) часто используются эфф. квази- (или псевдо-)спиновые гамильтонианы (КСГ). Применение КСГ основано на формальной аналогии между спиновыми операторами и операторами, действующими в пространстве состояний (*волновых функций*) к.-л. квантовой системы.

Квазиклассический спиновый гамильтониан обусловлен наличием у электронов или нуклонов собственного дипольного магн. момента μ (см. *Магнетизм микрочастицы*), к-рый посредством магнитомеханич. отношения связан с их спином s : $\mu = -g\mu_B s$ (g — *Ланде множитель*, μ_B — электронный μ_B или ядерный μ_B *Ланде магнетон*). Квазиклассичность этой части С. г. означает, что все перечисленные взаимодействия выражаются через магн. моменты частиц μ , к-рые могут иметь природу, отличную от спиновой (напр., *суперпарамагнетизм*), тогда как обменная часть С. г. имеет чисто квантовую природу и принципиально невозможна в системе частиц, не обладающих полупревальным спином. В квазиклассический С. г. входят: взаимодействие микрочастиц с внеш. магн. полем (см. *Веисама эффект*); *спин-орбитальное взаимодействие* электрона, находящегося в кулоновском поле ядра и др. электронов; *сверхтонкое взаимодействие* магн. моментов электронов и ядер; магн. *диполь-дипольное взаимодействие* в системе спинов электронов или ядер (иногда учитываются и взаимодействия более высокой мультипольности). В обычных условиях все эти релятивистские взаимодействия малы по сравнению с кулоновским *обменным взаимодействием*. Кроме того, малы члены, включающие взаимодействие с магн. моментами ятер, т. к. $\mu_B \ll \mu_N$. Учт. так или иначе членов С. г. важен, напр., в атомной и молекулярной спектроскопии и многих резонансных явлениях, где они приводят к расщеплению энергетич. уровней и уширению резонансных линий.

Эффективный одноузельный спиновый гамильтониан. В физике магн. явлений осн. роль играют ионы (атомы) элементов переходных групп и редкоземельных элементов с частично заполненными d - или f -оболочками — т. н. парамагн. ионы (ПМИ). Они обладают

отличным от нуля полным спином $S = \sum_{i=1}^n s_i$, где n —

число несвязанных электронов в оболочке, s_i — оператор спина i -го электрона. Суммарное спиновое квантовое число ПМИ $S = \sum s_i$. Энергия свободного ПМИ определяется в основном зеемановским и спин-орбитальными взаимодействиями, тогда как энергия того же атома (иона) в твёрдом теле выражается с помощью «одночастичного» (точнее, одноузельного) эффективного С. г. [М. Прайс (М. Pryce), 1950]

$$\mathcal{H} = \mu_B g_{\text{эф}} H^z S^z + \mu_B^2 \lambda_{\text{эф}} H^z H^2 + D_{\text{эф}} S^z S^z, \quad (1)$$

$$\alpha, \beta = x, y, z,$$

в k -ром полностью исключены орбитальные степени свободы (их вклад во 2-м порядке теории возмущений определяет коэф. $\lambda_{\text{эф}}$), H^z и S^z — проекции векторов внеш. магн. поля и полного спина на ось координат. Это связано с действием кулоновского *внутрикристаллического поля*, создаваемого немагнитным окружением, благодаря k -рому спин-орбитальное взаимодействие ПМИ существенно ослабляется. Если осн. состояние ПМИ является, напр., орбитальным синглетом, то происходит полное «вырождение» орбитальных моментов.

Первое слагаемое в (1) соответствует зеемановской энергии, где $g_{\text{эф}} = 2(\delta_{\text{эф}} + \lambda_{\text{эф}})$, $\delta_{\text{эф}}$ — Кронекера символа; второе — энергии, определяющей т. п. *ванфлэковский парамагнетизм*, третье — энергии d и o и n и o *и магнитной анизотропии*, характеризующей тензором $D_{\text{эф}} = \lambda^2 \lambda_{\text{эф}}$ (λ — константа спин-орбитального взаимодействия). Число разл. независимых g -факторов и констант анизотропии одинаково и определяется типом локальной симметрии окружения. В случае кубич. симметрии имеется всего одна константа, $D_{\text{эф}} = D \delta_{\alpha\beta}$, третье слагаемое в (1) вырождается в число $dS(S \pm 1)$ и вклад в (1) начинается с членов 4-го порядка $D_{\text{эф}} S^x S^y S^z S^x$ ($\alpha, \beta, \gamma, \delta = x, y, z$). В случае аксиальной симметрии таких констант две: $D_{\text{эф}} = D_{\parallel} \delta_{\alpha\beta}$ ($D_{\parallel} = D_{\parallel}$, $D_{\perp} = D_{\perp}$). В случае более сложной симметрии вклад в (1) могут давать более высокие степени спиновых (дипольных) операторов, а также квадратные и др. тензорные операторы, что особенно важно для больших значений S и высокой симметрии внутрикристаллич. поля. Микроскопич. расчёт $g_{\text{эф}}$ и $D_{\text{эф}}$ сложен, и они обычно задаются в С. г. феноменологически.

Обменный спиновый гамилтониан атомов и молекул. Обменный С. г. имеет чисто квантовую природу и не обладает классич. аналогом. Он обусловлен *тождественности принципом* (квантовая неразличимость одинаковых микрочастиц) и *Паули принципом*. Полная волновая ф-ция системы фермионов (электронов или кулонов), образующих электронную или ядерную подсистему твёрдого тела, должна быть антисимметричной по отношению к перестановке координат и спинов любой пары частиц. Этим обусловлено появление в собств. значениях энергий системы доп. обменных вкладов. Однако, согласно П. Дираку (P. Dirac, 1926), можно избежать сложной процедуры антисимметризации и ограничиться простым произведением одночастичных волновых ф-ций, если добавить к исходному гамилтониану оператор обменного взаимодействия, построенный только на спиновых операторах входящих в систему фермионов. Структура обменного С. г. определяется тем, что для любой пары частиц p, q со спином $1/2$ оператор перестановки (транспозиции) орбитальной (координатной) волновой ф-ции имеет вид: $P_{pq} = \pm 1/2 (1 + S_p S_q)$, где S_p и S_q — векторные спиновые операторы частиц p и q .

Простейшим примером обменного С. г. является гамилтониан системы двух взаимодействующих друг с другом и с ядрами электронов (напр., в атоме Не или молекуле H_2):

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 - 2J S_1 S_2, \quad (2)$$

Он описывает зависимость энергии этой системы от взаимной ориентации спинов S_1 и S_2 электронов и учитывает лишь кулоновское взаимодействие.

Обменный спиновый гамилтониан твёрдых тел. Обобщение простейшего С. г. (2) было дано В. Гейзенбергом (W. Heisenberg, 1928) и независимо Я. И. Френкелем (1928) для описания сильно магнитных свойств неких-рых твёрдых тел, содержащих ПМИ. При этом учитывалось только кулоновское взаимодействие в системе многих d (или f)-электронов и полностью пренебрегалось влиянием s -электронов проводимости. Соответствующий С. г. магн. диалектрина имеет вид (см. Гейзенберга модель):

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 - \sum_{i,j} J_{ij} S_i S_j, \quad (3)$$

где \mathcal{H}_0 — константа, $S_i (S_j)$ — векторный оператор полного спина ПМИ в узле $i(j)$, J_{ij} — обменный интеграл, зависящий только от расстояния между узлами i и j ($J_{ij} = 0$).

Несмотря на простоту, С. г. (3) качественно правильно описывает магн. упорядочение не только в магн. диалектриках, но и в неких-рых др. веществах, где учёт обменного взаимодействия внутри подсистемы d - или f -электронов уже недостаточен.

Обобщённый спиновый гамилтониан. Дальнейшее обобщение С. г. (3) для магн. диалектриков можно получить при учёте не только обменного, но и релятивистского межзонного взаимодействия. Этот С. г. может быть получен с помощью *волновой теории* для вырожденного уровня в операторной форме (Н. Н. Боголюбов, С. В. Тябликов, 1949). Обменный интеграл становится тензором $J_{ij}^{\alpha\beta}$, симметричная часть k -рого описывает эффекты обменной магн. анизотропии, а антисимметричная часть, представляемая вектором $D_{ij}^{\alpha\beta}$, описывает явление *слабого ферромагнетизма* в магнетиках (опред. симметрия [И. Е. Дзялошинский, 1957; Т. Морья (T. Moriya), 1960]. Соответствующий добавочный член к С. г. (3) имеет вид $\sum_{ij} (D_{ij}^{\alpha\beta} S_i S_j)$. Число незав.

всех компонентов симметричной части тензора $J_{ij}^{\alpha\beta}$ определяется типом симметрии кристаллич. решётки. В кристаллах кубич. симметрии всего одна компонента $J_{ij}^{\alpha\beta} = J_{ij} \delta_{\alpha\beta}$. В случае одноосной анизотропии $J_{ij}^{\alpha\beta} = J_{ij}^{\alpha\beta} \delta_{\alpha\beta}$, причём $J_{ij}^x = J_{ij}^y = J_{ij}^z$ (J_{ij}^x — продольная, J_{ij}^y — поперечная компоненты). Соответствующий последнему случаю С. г. с учётом зеемановского взаимодействия имеет вид:

$$\mathcal{H} = -g \mu_B \sum_i (H S_i) - \sum_{ij} \left\{ J_{ij}^x S_i^x S_j^x + J_{ij}^y (S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z) \right\}; \quad (4)$$

здесь H — постоянное и однородное внеш. магн. поле. С. г. (4) описывает ферро- или антиферромагнетизм в зависимости от знака обменных констант $J_{ij}^{\alpha\beta}$, k -рые рассматриваются как феноменологич. константы теории (их микроскопич. расчёт представляет самостоят. сложную задачу). Частные случаи С. г. (4) соответствуют известным моделям магн. веществ; напр., при $J_{ij}^x = J_{ij}^y = J_{ij}^z$ С. г. (4) сводится к С. г. изотропной модели Гейзенберга (3), при $J_{ij}^x = 0$ — к С. г. *Изинга модели*, при $J_{ij}^y = 0$ — к С. г. т. н. поперечной, или $X Y$ -модели. В боль-

шнестве случаев рассматривается приближение, когда величин J_{ij} отличны от нуля, лишь если узлы i и j являются ближайшими соседями и $J_{ij}^a = J^a$. Отношение $\xi = J^a / J^b$ наз. константой межионной магн. анизотропии. В более общем случае С. г. включает члены, описывающие одноионную анизотропию [см. третье слагаемое в (1)]. При $|\xi| < 1$ С. г. (4) описывает (анти)ферромагнетик типа лёгкая ось, при $|\xi| > 1$ — типа «лёгкая плоскость».

В более высоких порядках теории возмущений к билинейному по спиновым операторам С. г. (4) могут добавляться т. н. негеёванберговские взаимодействия в виде полилинейные формы вида $\sum_{i,j,k,\dots} A_{ijk\dots}^{(n)} S_i^a S_j^b S_k^c \dots$ (здесь $A_{ijk\dots}^{(n)}$ — численные коэф.),

называемые многоспиновыми взаимодействиями и существующие, напр., для описания спиновой системы *квантового кристалла* He^3 . В случае спина $S \geq 1$ возможны также негеёванберговские слагаемые вида $\sum_{i,j} A_{ij}^{(n)} (S_i S_j)^n$, содержащие все независимые спиновые инварианты до порядка $2S$ включительно [Э. Шрёдингер (E. Schrödinger), 1940]. Напр., при $S = 1$ это даёт биквадратный обмен.

Обобщение С. г. (4), учитывающее *спин-фононное взаимодействие* в магнетике, возможно на основе кристаллографической симметрии, описывающей изменение обменных констант при смещении ПМИ из своих равновесных положений. Др. обобщение С. г. (4) возможно, если при разбиении магнетика на две или более магн. подрешётки обменные константы J_{ij}^{ab} могут иметь разл. величины и знаки внутри и между подрешётками (напр., в простом антиферромагнетике $J_{ij} < 0$ между подрешётками, тогда как $J_{ij} > 0$ внутри подрешёток).

Величин J_{ij}^{ab} могут быть анизотропны не только в спиновом (по индексам α, β), но и в координатном (по индексам i, j) пространстве (см. *Свойства магнетики*). В примесных или неупорядоченных магнетиках обменные константы могут быть случайно распределёнными величинами (см. *Спиновое стекло*). При теоретич. расчётах иногда удобно использовать вместо исходных решёточных (дискретных) С. г. (3) и (4) их континуальный (непрерывный) аналог; для этого вводится зависящий от времени t оператор плотности магн. момента $M(r,t) = -\mu_B \sum_i S_i \delta(r - r_i)$, $\delta(r) = \text{дельта-функция}$,

$S_i = S_i(t)$, $r_i = r_i(t)$, к-рый затем усредняется по физически бесконечно малому объёму [Ч. Херринг, Ч. Киттель (C. Herring, C. Kittel), 1951]. В результате возникает плотность макроскопич. магн. момента $M(r,t)$, через к-рую (вместе с её производными) выражаются обычно квазиклассич. феноменологич. С. г., получаемые в виде разложений по магн. инвариантам данной решётки.

Квазиспиновый гамильтониан. Использование КСГ прежде всего связано с относит. простотой и низкой размерностью $m = 2S + 1$ алгебры $SU(m)$ спиновых операторов. Для С. г. (КСГ) хорошо разработаны теорет. методы вычислений, в т. ч. квазиклассич. метод приближённого *отрочичного квантования*, вращательный и функциональные методы, методы двухвременных и причинных *Грина функций*, разл. варианты диаграммной техники. Применение КСГ особенно удобно в тех случаях, когда система обладает небольшим числом $2S + 1$ (S — квантовое число квазиспина) разл. квантовых состояний, к-рые описываются собств. значениями оператора продольной компоненты оператора квазиспина S^z (от $-S$ до S) или оператора числа спиновых отклонений $n = S - S^z$ (от 0 до $2S$). Операторы

поперечных компонент квазиспина $S^x = S^y \pm iS^z$ играют роль операторов рождения и уничтожения квазиспиновых отклонений в S^z -представлении и переводят систему из одного состояния в другое. Для наб. распределённого случая двухуровневой системы ($S = 1/2$) квазиспиновые операторы S^x и S^y точно совпадают с а и л-операторами, коммутующими подобно бозе-операторам для разл. состояний ($i \neq j$) и антикоммутирующими подобно ферми-операторам для совпадающих состояний ($i = j$).

В методе КСГ пространство состояний системы является конечномерным, а энергетич. спектр — ограниченным (хотя и не обязательно дискретным). Определ. трудности связаны с кванематич. свойствами спиновых операторов (условием нормировки и т. п.), а также с необходимостью использования обобщённой квантовой статистики с макс. числом заполнения $2S$ (случай $S = 1/2$ соответствует Ферми — Дирака статистике, $S \rightarrow \infty$ — Бозе — Эйнштейна статистике). Физическая возможность введения квазиспинового описания в реальных системах мн. ферми- или (реже) бозе-частиц обусловлена особенностями структуры гамма-функции взаимодействия и пространства собств. ф-ций, позволяющих полностью исключить одночастичные ферми- или бозе-операторы и ввести с их помощью операторы квазиспина или паули-операторы. При вычислениях на основе КСГ также возможно использование соответствующих квазибозонов или квазифермионов представлений спиновых операторов.

Характерные примеры применения метода КСГ: 1) энергия ПМИ в немагн. окружении в случае, когда его основным орбитальным состоянием является не синглет, а вырожденный дублет, описывается вместо (1) эффективным КСГ вида

$$\mathcal{H} = 2\mu_B H^z S^z + \mu_B H^2 \sigma^2 + \lambda S^z \sigma^2, \quad (5)$$

где S^z — оператор z-компоненты обычного спина ПМИ, σ^2 — оператор z-компоненты квазиспина ($\sigma = 1/2$), действующий в двумерном пространстве волновых ф-ций вырожденного орбитального дублета.

2) Зарядово-независимое (изотопически инвариантное) взаимодействие в системе нуклонов описывается КСГ вида (3) с заменой S_i на τ_i , где τ_i — оператор *нуклонического спина* (В. Гейзенберг, 1932), действующий в пространстве волновых ф-ций протона и нейтрона. В J_{ij} входят как истинное обменное взаимодействие вида (3), обусловленное фермионной природой нуклонов, так и другие зависящие от спина (т. н. тензорные) взаимодействия (см. *Ядерные силы*).

3) Энергия (анти)сверхпроводника с водородной связью (напр., KH_2PO_4 или NaNO_3), обнаруживаемая *структурной модой передов.* описывается частным случаем КСГ вида (4) — моделью Инзига в полупроводн. слое [П. де Жен (P. de Gennes), 1963]. Если внеш. поля игнор. интеграл тунелирования Φ протона между двумя симметричными минимумами (максимами) одностороннего потенциала. Операторы квазиспина для $S = 1/2$ определены в двумерном пространстве симметричных или антисимметричных по «ямам» волновых ф-ций, описывающих распределение осн. состояний из дублет с энергиями соответственно σ_+ и σ_- ($\sigma_+ > \sigma_-$, причём $Q \approx \sigma_- - \sigma_+$).

4) Энергия сверхпроводника в простейшем варианте *Вардена — Купера — Шриффера модели* может быть представлена в виде частного случая КСГ (4) — поперечной или ХУ-модели [П. Андерсон (P. Anderson), 1958]. Роль обменного интеграла играет матричный элемент взаимодействия притяжения между куперовскими парами (см. *Купера эффект*), а роль операторов квазиспина — операторы рождения, уничтожения и числа этих пар. Свойство «ферминости» квазиспиновых операторов для $S = 1/2$ в одном импульсном состоянии отражает требование принципа Паули.

5) Энергия решётчного квантового неидеального бозе-газа (напр., состоящего из атомов He^4), проявляю-

щего свойство сверхтекучести, также может быть выражена с помощью КСГ (4) для частного случая ферромагнетика типа «лёгкая плоскость» [Х. Мацубара, Х. Мацубара (H. Matsubara, H. Matsuda), 1956] для $S = 1/2$. Роль внутр. поля играют хим. потенциал и аннизотропия, а обменного интеграла — энергия парного притяжения бозонов. Свойство сферичности паули-операторов в одном узле решётки отражает наличие в нём сильного отталкивания (типа потенциала «твёрдых сфер»).

6) Клиффорда, энергия парных взаимодействий атомов — ближайших соседей в бинарном твёрдом растворе или сплав может быть записана в виде продольной (изинговской) части КСГ (4) с $S = 1/2$ (Э. Изинг, 1925). Оператор квазиспина S^z описывает два состояния, соответствующих заполнению данного узла атомом одного или другого типа; роль обменного интеграла играет энергия упорядочения. На основе этой модели можно описать фазовый переход типа порядок — беспорядок ($T > 0$) с образованием сверхрешётки или распадение на две фазы разл. состава.

С помощью того же изинговского КСГ с $S = 1/2$, но с учётом полной потенциальной энергии парных взаимодействий атомов одного типа (дальдействующее притяжение и короткодействующее отталкивание) [Т. Ли, Ч. Янг (T. Lee, C. Yang), 1952] можно описать фазовый переход типа конденсации для классич. идеального решётчного газа, при этом оператор $n = 1/2 - S^z$, как правило, описывает два возможных состояния в узле: занятое ($n = 1$) и свободное ($n = 0$).

7) С помощью КСГ формулируются также задачи о взаимодействии экситонов в молекулярных кристаллах (А. М. Агранович, В. Топич, В. Тоичич, 1976), магн. упорядочения в f -металлах с синглетными осн. состоянием во внутрикристаллич. поле [И. Янг, Б. Купер (Y. Wang, B. Cooper), 1968], квадрупольном упорядочении в твёрдом ортоборате [Дж. Рейч, Р. Эттерс (J. Reich, R. Ethers), 1967], фазовом переходе в сверхизлучательный (лазерный) режим для взаимодействующих ал.-магн. излучения с термостатом на двумерных атомах [Р. Дикке (R. Dicke), 1954].

Лит.: Д а л д у Л. Д., И н ф и н т Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1988, § 9—11, 16; Д и р а к П. А. М., Принципы квантовой механики, пер. с англ., 2 изд., М., 1979, гл. 8; Х и л л Т., Статистическая механика, пер. с англ., М., 1960; А л ь т у н у л о в С. А., К о з ь м ь р е в В. М., Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп, 2 изд., М., 1972; Т а у л е с Д., Квантовая механика систем многих частиц, пер. с англ., М., 1963; Т я б л и н о в С. В., Методы квантовой теории магнетизма, 2 изд., М., 1973; А г р а н о в и ч В. М., Теория экситонов, М., 1968; Б о н о с с е н и я С. В., Магнетизм, М., 1971; У а й т Р., Квантовая теория магнетизма, пер. с англ., 2 изд., М., 1985; В а к с В. Г., Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков, М., 1973; И с и н г Э. А., Статистическая физика, пер. с англ., М., 1973, гл. 8; В а р ь х а т а р В. Г., К р и в о р у ч к о в В. Н., Я б л о н с к и й Д. А., Функции Грина в теории магнетизма, К. 1984; И з м о в о Ю. А., С м е р я к о в Ю. Н., Статистическая механика магнитоупорядоченных систем, М., 1967; И з а г а е в В. Л., Магнетизм со сложными обменными взаимодействиями, М., 1988. Ю. Г. Рубой.

СПИНОР (от англ. spin — вращаться) — элемент пространства спинорного представления группы вращений. Вращений группа $SO(n)$ при $n \geq 3$ двусвязна. Её односвязная накрывающая называется спинорной группой $Spin(n)$. Каждое линейное представление $SO(n)$ порождает представление $Spin(n)$; однако часть линейных представлений $Spin(n)$ порождается двузначными (проективными) с мультипликатором ± 1 представлениями $SO(n)$ — её спинорными представлениями. Простейшее спинорное представление имеет размерность $2^{n/2-1}$ (где [...] — символ целой части числа) и реализуется в Клиффорда алгебре K_n степени $2^{n/2-1}$. Оно неприводимо для нечётных n и раслагается в сумму двух неэквивалентных представлений одинаковой размерности для чётных n .

Существуют два типа S : S_+ , связанные с группой $SO(n)$ — группой вращений n -мерного евклидова пространства, и S_- , связанные с группой $SO(p, q)$ ($p + q =$

$= n$) — группой «вращений» псевдоевклидова пространства $M_{p,q}^n$, сохраняющих квадратичную форму:

$$x^2 + \dots + x^2 - x^2 - \dots - x^2.$$

В R^3 фазике наиб. употребительны S_+ в пространстве R^3 (С. группы $SO(3)$) (нерелятивистская квантовая механика) и в пространстве Минковского $M_{1,3}^4$ (С. собственной Лоренца группы в релятивистской теории).

Спинор в R^3 . Простейшее спинорное представление (спинорное представление ранга 1) двумерно [т. к. $Spin(1) \sim SU(2)$]. С. ранга 1 характеризуется парой (комплексных) чисел ξ^1, ξ^2 . При повороте на угол φ вокруг оси с направляющим единичным вектором $n = (n_1, n_2, n_3)$ С. ранга 1 преобразуется по ф-ле

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi^1 \\ \xi^2 \end{pmatrix} \rightarrow \xi' = g(n, \varphi) \xi \in SU(2) \quad (1)$$

с помощью матрицы

$$g(n, \varphi) = \cos(\varphi/2) + i \sin(\varphi/2) \sigma_j \quad (2)$$

где $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$, $\sigma_j (j = 1, 2, 3)$ — Паули матрицы. При повороте на угол 2π С. ξ переходит в $-\xi$, что свидетельствует о неопределённости знака С., т. е. о двузначности представления. Выражение (2) задаёт представление $SO(3)$, как следует из коммутат. соотношений для матриц Паули. В этом представлении матрица $(i/2)\sigma_j$ является генератором поворота вокруг оси j . Преобразование (1) сохраняет билинейную форму $(\xi, \eta) = \xi^1 \eta^1 - \xi^2 \eta^2$, определённую на двумерных векторах (кватервариантных) ξ и η . Это позволяет ввести в линейном пространстве таких векторов кососимметрическую «метрику»

$$\epsilon_{ab} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta = 0, 1,$$

и ковариантные С. $\xi_a = \epsilon_{ab} \xi^b$, преобразующиеся с помощью арматов сопряжённой матрицы $g^t(n, \varphi)$. Тогда билинейная форма естественно интерпретируется как скалярное произведение:

$$(\xi, \eta) = \xi^a \epsilon_{ab} \eta^b = \xi^1 \eta^1 - \xi^2 \eta^2$$

(по повторяющимся индексам подразумевается суммирование).

В качестве базиса в пространстве С. ранга 1 можно выбрать собств. векторы

$$\xi^+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \xi^- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

матриц $(1/2)\sigma^2$ и $(1/2)\sigma_3$, допускающих естеств. интерпретацию квадрата вектора спина и его z -проекции; собств. значениями будут $3/4 = 1/2(1 + 1/2)$ и $\pm 1/4$ соответственно. Поэтому С. ранга 1 описывают частицы со спином $1/2$.

С. старших рангов строятся по аналогии с теорией тензоров. Кватервариантным спинором ранга r наз. набор 2^r (комплексных) чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, преобразующихся по закону:

$$\xi^{\alpha_1, \dots, \alpha_r} \rightarrow \xi'^{\alpha_1, \dots, \alpha_r} = g_{\beta_1}^{\alpha_1} \dots g_{\beta_r}^{\alpha_r} \xi^{\beta_1, \dots, \beta_r},$$

где g_{α}^{β} — элементы матрицы $g(n, \varphi)$. В алгебре С. можно ввести операции, аналогичные операциям в тензорной алгебре: поднятие и опускание индексов, свёртка и т. д. С. $\xi^{\alpha_1, \dots, \alpha_r}$ ранга r наз. симметрическим, если его компоненты не меняются при любой перестановке индексов. В пространстве симметрических С. реализуются все неприводимые представления группы вращений веса l , $2l = r$.

Спинор в M^4 . Два простейших неупорядоченных (полуспинорных) представления $SO(3, 1)$ двумерны и обозначаются столбцами ξ^{α} и $\zeta^{\dot{\alpha}}$ соответственно с непунктирными и с пунктирными индексами. При пространственных поворотах ξ^{α} преобразуются (как и S в R^3) с помощью матрицы (2) , а при специальных Лоренца преобразованиях — гиперболически. Поворота на угол φ в плоскости (x_0, x_1) — с помощью матрицы h :

$$h(n, \varphi) = \text{ch}(\varphi/2) - n(\sigma)\text{sh}(\varphi/2).$$

Пунктирные $S, \xi^{\dot{\alpha}}$, преобразуются с помощью комплексно сопряженных матриц d^* и h^* соответственно.

Коссимметрическая матрица $e_{\alpha\dot{\beta}}$ позволяет определить компоненты пунктирных S . При пространственной инверсии $(x_0, x) \rightarrow (x_0, -x)$ пунктирные и непунктирные S переходят друг в друга: $\xi^{\alpha} \rightarrow i\xi_{\alpha}$, $\zeta^{\dot{\alpha}} \rightarrow i\zeta^{\dot{\alpha}}$.

Включение инверсий означает переход от собств. групп Лоренца $SO(3, 1)$ к группе Лоренца $O(3, 1)$. Поэтому простейшее спинорное представление $O(3, 1)$ четырехмерно и образовано биспинором $\xi_{\alpha} \otimes \xi_{\dot{\beta}}$. (\otimes — знак тензорного произведения), обычно записываемым в виде столбца:

$$\Psi = \begin{pmatrix} \xi_{\alpha} \\ \xi_{\dot{\beta}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi \\ \chi \end{pmatrix}.$$

Инвариантные и ковариантные билинейные формы в пространстве биспиноров строятся с помощью Дирака матриц γ^{μ} , $\mu = 0, 1, 2, 3$, $\gamma^{\mu} = \gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\nu}$ и определения дираковского сопряжения $\bar{\psi} = \psi^{\dagger}\gamma^0$ ($\dagger + \dagger$ означает эрмитово сопряжение). Так, формы $\bar{\psi}\psi$, $\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi$, $\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu}\psi$ — есть соответственно скаляр, псевдоскаляр и 4-вектор относительно преобразований из $O(3, 1)$.

Помимо дираковского вводит майорановское сопряжение $\Psi_M = \Psi^T C$ (T — означает транспонирование), где C — матрица *зарядового сопряжения*. Майорановский Ψ_M и S наз. S . наз. S . для k -рого Ψ_M пропорционален Ψ (множитель пропорциональности зависит от представления матриц Дирака), и частицы, в майорановском представлении (где ψ^{\dagger} и $\psi^{0\dagger} = [\psi^{\dagger}, \psi^{\dagger}]$ вещественны) компоненты майорановского S вещественны.

Вейлевский S наз. S . наз. S . удовлетворяющий соотношению $\Psi_{\pm} = (1/2)(I \pm \gamma^0)\Psi$, или $\Psi_{\pm} = (1/2)(I \pm \gamma^0\gamma^i)$, где I — единичная матрица (соответственно правой и левой S). Число его компонент также вдвое меньше обычного; он используется в теориях с киральной симметрией.

В пространстве биспиноров можно задать линейное релятивистски инвариантное ур-ние, описывающее частицу со спином $1/2$ (спинорные частицы), с ненулевой массой — Дирака уравнение, с нулевой массой — Вейля уравнение.

S ., связанные с многомерными пространствами, находят применение в теории галактики, Калуцы — Клейна теории, теории суперструн и т. д. Многообещающие применения теории S . связаны с теорией *гипотез*.

Спинорные многообразия. Глобально спинорное поле можно задать не на любом многомерном пространстве. Существование таких пространств (спинорных многообразий, см. *Расщепление*) определяется топологией, инвариантами.

Первые упоминания двузначной природы группы вращений восходят к Л. Эйлеру (L. Euler) (параметризация группы вращений углами Эйлера). В работах О. Родригеса (O. Rodrigues), У. Гамильтона (W. Hamilton), А. Кэли (A. Cayley), У. Клиффорда (W. Clifford) и др. были получены важные результаты, изшедшие естеств. продолжением в рамках теории S . Построение спинорных представлений в инфинитезимальной

форме проведено Э. Картаном (E. Cartan, 1913). Дальнейшее развитие теории S . инициировалось открытием спина электрона (1925) и появлением ур-ий П. Дирака (P. Dirac) и Г. Вейля (H. Weyl). Спинорное исчисление было построено в работах Б. Ван-дер-Ваerdena (B. van der Waerden) и др. Термин « S .» предложен Э. Эрештестом (P. Ehrenfest, 1929).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; Гельфанд И. М., Миняев Р. А., Шапиро З. Я., Представления группы вращений и группы Лоренца и их приложения, М., 1958; Ван дер Ваerden Б., Принципы кванта и спин, в кн.: Теоретическая физика 20 века, М., 1962; Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Пятаевский Л. П., Релятивистская квантовая теория, ч. 1, М., 1968; Дирак П. А. М., Спиноры в гильбертовом пространстве, пер. с англ., М., 1978; Вейль Г., Рунд Г. В., Спиноры и пространство-время, пер. с англ., (т. 1), М., 1987; (т. 2) — Спиноры и пространство-время. Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства-времени, пер. с англ., М., 1988; Вейль Г., Траутманн А., The spinorial sleasbow, Springer, N. Y., 1988. М. И. Моисевицкий.

СПИН-ОРБИТАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — взаимодействие частиц, зависящее от величины и взаимной ориентации их орбитального и спинового моментов кол-ва движения и приводящее к т. н. тонкому (мультиплетному) расщеплению уровней энергии системы (см. *Тонкая структура*). С.-о. в — релятивистский эффект; формально оно получается, если энергию быстро движущегося во внеш. поле частицы находить с точностью до v^2/c^2 , где v — скорость частицы.

Наглядное физ. истолкование С.-о. в. можно получить, рассматривая, напр., движение электрона в атоме водорода. Электрон обладает собств. моментом кол-ва движения — спином, с к-рым связан спиновый магн. момент. Электрон движется вокруг ядра по нек-рой орбите (примем этот полуклассич. образ). Обладаящее электр. зарядом ядро создаёт кулоновское электр. поле, к-рое должно оказывать воздействие на спиновый магн. момент движущегося по орбите электрона. В этом можно убедиться, если мысленно перейти в систему отсчёта, в к-рой электрон покоится (т. е. в систему, движущуюся вместе с электроном). В этой системе отсчёта ядро будет двигаться и как locally движущийся заряд порождал магн. поле H , к-рое будет воздействовать на магн. момент и электрона. Электрон получит дополнит. энергию $\Delta\epsilon$, обусловленную этим взаимодействием и зависящую от ориентации μ : $\Delta\epsilon = -\mu H = -\mu_H H$. Т. к. проекция μ_H магн. момента μ на направление H может принимать два значения ($\pm 1/2$, в единицах \hbar), то С.-о. в. приводит к расщеплению уровней энергии в атоме водорода (и водородоподобных атомах) на два близких подуровня — к дублетной структуре уровней. У многоэлектронных атомов картина тонкого расщепления уровней энергии оказывается более сложной. Атомы щелочных металлов, у к-рых полный спин электронов равен $1/2$, также обладают дублетной структурой уровней энергии.

С.-о. в. существует и у нейтральных частиц, напр. у нейтронов, имеющих и орбитальный и спиновый механич. моменты. Весьма существенно С.-о. в. в атомных ядрах, вклад к-рого в полную энергию взаимодействия велик (достигает 10%). В. И. Григорьев.

СПИНОРНАЯ ЧАСТИЦА — частица с полуцелым спином. Часто под С. ч. понимают частицу со спином $1/2$ (электрон, протон, кварк и т. д.). В квантовой механике волновая ф-ция С. ч. подчиняется Дирака уравнению или (для частиц с нулевой массой) Вейля уравнению. В квантовой теории поля С. ч. является квантом спинорного поля.

СПИНОРНОЕ ПОЛЕ — набор физ. полей, преобразующихся в каждой точке пространства-времени при пространственных поворотах системы координат по представлениям группы вращений с полуцелым индексом (см. *Вращенная группа*). Квантами С. п. в квантовой теории поля являются спинорные частицы.

СПИН-СПИНОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — магн. взаимодействие между спиновыми магн. моментами эле-

кτροнов, атомных ядер, парамагн. атома и ионов. Энергия С.-с. в. зависит от взаимной ориентации спинов этих частиц. Благодаря своей релятивистской природе С.-с. в., как правило, значительно слабее др. взаимодействий (электростатических, обменных и др.), определяющих структуру энергетич. уровней атомных и молекулярных систем. Поэтому С.-с. в. определяет обычно лишь малое расщепление или уширение спектральных линий (см. *Радиоспектроскопия, Спектроскопия*). В простейших случаях величина С.-с. в. определяется диполь-дипольным взаимодействием спиновых магнитных моментов μ_i и μ_j ; каждый из i, j имеет энергию порядка $\mu_i \mu_j \sim \mu_B^2 / r^3$, где r — расстояние между частицами. Для типичных атомных масштабов величина $\mu_i \mu_j$ оказывается порядка 10^{-4} – 10^{-5} , 10^{-7} – 10^{-8} и 10^{-11} эВ соотв. для электрон-электронного, электронно-ядерного и ядерно-ядерного взаимодействий.

Электрон-электронное С.-с. в. в свободных атомах и ионах приводит лишь к малому сдвигу энергетич. уровней, не вызывая их расщепления. В молекулах, где центр симметрии нарушен, такие расщепления возникают и дают вклад в мультиплетную тонкую структуру спектров (т. н. S -уровни; см. *Молекула*). Аналогичный эффект возникает и при понижении симметрии во *внутрикристаллическом поле* твёрдого тела. Электронно-ядерное С.-с. в. между орбитальными электронами атома (иона, молекулы) и обладающими спином ядром атома приводит к *сверхтонкой структуре* спектров, обусловленной зависимостью энергии атома от ориентации ядерного спина I в магн. поле, созданном суммарным спином электронов S (см. *Сверхтонкое взаимодействие*). Аналогичная сверхтонкая структура наблюдается и в спектрах *электронного парамагнитного резонанса*, где она обусловлена С.-с. в. несвязанных электронов парамагн. центров (см. *Парамагнетизм*) как с их собств. ядрами, так и с ядрами ближайших соседей (с у п е р с в е р х т о и к а с т р у к т у р а).

В электронных парамагнетиках С.-с. в. между парамагн. центрами в значит. степени определяет форму и ширину линий ЭПР. В этом случае принято понимать термин «С.-с. в.» более широко: кроме магнитной (диполь-дипольной) энергии к нему относят и обменное взаимодействие, к-рое также зависит от взаимной ориентации спинов и формально рассматривается как «сверхдипольное».

С.-с. в. между ядрами атомов, входящих в кристаллич. решётку твёрдого тела, определяет форму линий *ядерного магнитного резонанса* и даёт информацию о структуре вещества и внутр. атомо-молекулярных движениях. В жидкостях быстрое тепловое движение атомов и молекул приводит к тому, что анизотропная часть ядерно-ядерного С.-с. в., усредняясь, уменьшается практически до нуля. Это ведёт к резкому сужению линий и повышению разрешающей способности ЯМР. Сходных результатов можно достигнуть и в твёрдых телах за счёт быстрого вращения образца либо с помощью спец. радиочастотных полей, застаивающих ядерные спины быстро менять свою ориентацию. Косвенное ядерное С.-с. в., обусловленное очень слабым взаимодействием ядерных спинов I_i и I_j через общую электронную систему молекулы, носит изотропный характер и поэтому не усредняется. Оно образует малые (~ 1 Гц) мультиплетные расщепления в спектрах ЯМР высокого разрешения. Эти расщепления не зависят от величины внеш. магн. поля и могут быть использованы для классификации и структурного анализа сложных молекул и их фрагментов.

С.-с. в. играет важную роль в динамике многочастичных спиновых систем. Оно приводит к взаимным переворотам взаимодействующих спинов (электронных либо ядерных), что обеспечивает процессы поперечной *релаксации магнитной, спиновой диффузии* и ведёт к установлению *спиновой температуры* в парамагн. твёрдых телах. С.-с. в. между электронами

парамагн. центров и окружающих ядрами определяет, кроме того, процессы магн. релаксации и дипачик. поляризации ядер (см. *Оверхаузера эффект*).

В магнитоупорядоченных веществах (ферро- и антиферромагнетиках) С.-с. в., наряду с внутрискристаллич. полем, даёт вклад в *магнитную анизотропию*, играет решающую роль в образовании магнитной доменной структуры. Существуют также соединения (в основном с участием редкоземельных элементов), магн. упорядочение в к-рых вообще обусловлено не обменным, а дипольным С.-с. в. (дипольные магнетики).

Лит.: Альтшулер С. А., Козырев В. Н., Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточной п. М., Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок, пер. с англ., т. 1–2, М., 1984; Лукиян А. Г., Федяев Э. И., ЯМР-спектроскопия, М., 1986. В. А. Ачарчин.

СПИН-ФЛИП ПЕРЕХОД (от англ. flip — щёлкать, хлопнуть; «схлопывание» магнитных подрешёток) — магнитный фазовый переход в сильном магн. поле, при к-ром разрушается антиферромагнетизм. При наложении возрастающего внеш. магн. поля перпендикулярно направлению лёгкого намагничивания антиферромагн. кристалла векторы намагниченности *магнитных подрешёток* кристалла начинают поворачиваться к направлению поля и в определённом поле (критич. магн. поле $H_{\text{св}} \approx H_c$, где H_c — эфф. поле обменного взаимодействия ионов) все магн. моменты ионов антиферромагнетика ориентируются вдоль поля (намагниченности подрешёток «схлопываются»). Антиферромагн. кристалл становится по существу ферромагнитным (рис. 1). Раз-

рушение антиферромагнетизма происходит, когда магн. энергия подрешёток во внеш. поле сравнивается с энергией обменного взаимодействия ионов. Эффективное обменное поле $H_{\text{св}}$, являющееся критич. полем С.-ф. п., разрушающим антиферромагнетизм, определяется из условия $kT_N = \mu H_{\text{св}}$, где T_N — темп-ра Нееля, $\mu \approx M_0 / N$ — величина порядка атомного магн. момента, M_0 — намагниченность насыщения магн. подрешётки,

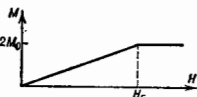
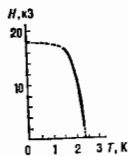


рис. 1. Зависимость намагниченности одноосного антиферромагнетика при $T = 0\text{К}$ от магнитного поля, перпендикулярного оси антиферромагнетизма. M_0 — намагниченность насыщения ферро-решётки, $H_{\text{св}} \approx H_c$ — критическое поле спин-флип перехода.

рушение антиферромагнетизма происходит, когда магн. энергия подрешёток во внеш. поле сравнивается с энергией обменного взаимодействия ионов. Эффективное обменное поле $H_{\text{св}}$, являющееся критич. полем С.-ф. п., разрушающим антиферромагнетизм, определяется из условия $kT_N = \mu H_{\text{св}}$, где T_N — темп-ра Нееля, $\mu \approx M_0 / N$ — величина порядка атомного магн. момента, M_0 — намагниченность насыщения магн. подрешётки,

рис. 2. Температурная зависимость критического поля для $\text{MnF}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($T_N \approx 2,3\text{К}$).



N — полное число узлов в кристаллич. решётке антиферромагнетика. При абс. нуле темп-ры обменная энергия по порядку величины равна kT_N . С ростом темп-ры величина обменного поля, а следовательно и критич. поле «схлопывания» подрешёток, уменьшается, обращаясь в нуль при $T = T_N$ (рис. 2). С.-ф. п. представляет собой, как правило, фазовый переход 2-го рода.

Лит.: Боровиц-Романов А. С., Антиферромагнетизм, в сб.: Итоги науки. Сер. физ.-мат. науки, в. 4, М., 1962; В о с о в с к и й С. В., Магнетизм, М., 1971. А. М. Надомченко.

СПИН-ФЛОН ПЕРЕХОД (от англ. flop — шлёпнуться, хлопнуть; «прокидывание» подрешёток) — магнитный фазовый переход, наблюдаемый в антиферромагнетиках при достаточно большом (критич.) значении внеш. магн. поля $H_{\text{св}}$, приложенного вдоль оси антиферромагнетизма, при к-ром направление намагниченности *магнитных подрешёток* поворачивается перпендикулярно ориентации поля $H_{\text{св}}$ (см. *Антиферромагнетизм*).

Этот переход обусловлен тем, что в антиферромагнетиках при $T \ll T_N$ (T_N — темп-ра Нееля) восприимчивость вдоль оси антиферромагнетизма χ_{\parallel} меньше восприимчивости χ_{\perp} в поперечном направлении, и при нек-ром значении магн. поля $H_{\text{цел}}$ разность магн. энергий $-1/2g(\chi_{\parallel} - \chi_{\perp})H^2$ сравнивается с энергией анизотропии, что и приводит к скачкообразному изменению ориентации спинов на угол $\pi/2$ (рис. 1).

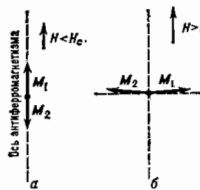


Рис. 1. «Переворачивание» магнитных подрешеток в анизотропном антиферромагнетике при внешнем магнитном поле $H < H_{\text{цел}}$ (а) и $H > H_{\text{цел}}$ (б).

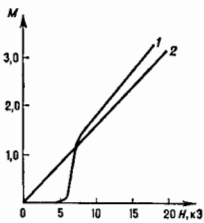


Рис. 2. Зависимость намагниченности M (в Гауссовой системе единиц) от напряженности внешнего магнитного поля для монокристалла $\text{CsCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ при $T = 1,57$ К; 1 — H_{\parallel} , 2 — H_{\perp} .

Это явление впервые наблюдалось экспериментально на антиферромагн. монокристаллах $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ с $T_N = 4,3$ К. На рис. 2 приведены зависимости магн. момента этого соединения от напряженности магн. поля, приложенного вдоль оси антиферромагнетизма (ось а) и перпендикулярно ей (ось б). При низких темп-рах $\chi_{\parallel} < \chi_{\perp}$, но при достижении $H_c = 6$ кОэ намагниченность вдоль оси а скачком возрастает (фазовый переход 1-го рода), после чего восприимчивость по осям а и б оказываются примерно одинаковыми, т. е. при $H_c > 6$ кОэ намагниченности подрешеток устанавливаются перпендикулярно полю.

Кратч. поле С.-ф. в. связано с внутр. эфф. полями антиферромагнетика. В случае простейшего легкоскопо антиферромагнетика $H_c = (2N_H N_A)^{1/2}$, где N_H — эфф. обменное поле, N_A — эфф. поле анизотропии.

Лит.: В о р о в и к - Р о м и н о в А. С., Антиферромагнетизм, в сб.: Итоги науки. Сер. Физ.-мат. науки, в. 4, М., 1962; В о н с о в с к и й С. В., Магнетизм, М., 1971; А. М. Иодко, Спин-Фононное Взаимодействие — взаимодействие электронных и ядерных спинов атомов твердого тела с упругими колебаниями кристаллической решетки. Последним в квантовомеханич. представлении соответствует поле фононов. Колебания решетки, тепловые или вызванные внеш. упругой волной, периодически изменяют расстояния между атомами, что приводит к модуляции как внутрискристаллического поля, так и взаимодействия между спинами электронов и ядер, т. е. к спин-спиновому взаимодействию.

С.-ф. в. обуславливает релаксационные процессы, приводящие к установлению теплового равновесия между системой спинов и решеткой, т. н. спин-решеточную релаксацию (см. Релаксация магнитная). Оно также оказывает влияние на положение и ширину спиновых уровней, приводя к сдвигу фактора спектроскопич. расщепления и изменению констант тонкого и сверхтонкого спиновых расщеплений. С.-ф. в. ответственно за поглощение энергии акустич. колебаний при акустическом парамагнитном резонансе (АПР).

Известно неск. механизмов С.-ф. в. Для электронных спинов парамагнитных ионов в т. н. слабоконцентрированных парамагнетиках (напр., примесных парамагн. ионов в диамагн. матрице), где взаимодействием между парамагн. ионами можно пренебречь, наиболее существенным является электр. механизм,

обусловленный модуляцией внутрикристаллич. электр. поля упругими колебаниями решетки. Осциллирующее поле нарушает орбитальное движение электрона и посредством спин-орбитального взаимодействия вызывает перераспределение спинов парамагн. ионов. Этот процесс связан с т. н. ван-Влекковским парамагнетизмом, обусловленным деформацией электронной оболочки иона. Механизм Ван Флека характерен для примесных ионов группы Fe и редких земель в диэлектрич. и полупроводниковых кристаллах (напр., Fe^{2+} в Al_2O_3 и MgO ; Cr^{3+} в GaAs). С.-ф. в. возникает в результате модуляции зеемановской энергии или взаимодействия электронной намагниченности с магн. полем, обусловленным ядерным магнитным моментом (см. Сверхтонкое взаимодействие).

В концентрированных парамагнетиках С.-ф. в. может осуществляться за счет модуляции колебаниями решетки магнитного дипольного или обменного взаимодействия между спинами, поскольку они зависят от расстояний между ионами (механизм Вальера). В случае диэлектриков этот механизм может конкурировать с ванфлекковским только для ионов с большим магн. моментом.

В магнитоупорядоченных веществах основную роль в С.-ф. в. играет модуляция упругими колебаниями решетки обменного взаимодействия между спинами. В свою очередь, коллективные колебания спинов (спиновые волны), распространяясь по кристаллу, вызывают смещение ионов решетки, что приводит к возникновению связанных т. н. магнитоупругих колебаний. Их интенсивность возрастает при совпадении частот спиновой и упругой волн с одинаковым волновым вектором.

Для атомов, ядра к-рых обладают неадиабатическим моментом, существенно С.-ф. в., обусловленное связью переменных градиентов внутрикристаллич. поля с квадрупольными моментами ядер. Квадрупольный механизм С.-ф. в. присущ диэлектрикам, слаболегированным полупроводникам и ряду металлов.

В проводящих средах (металлах, сильнолегированных полупроводниках) с большой концентрацией электронов проводимости помимо электр. механизма С.-ф. в. существует т. н. механизм Ольфера — Рубина, связанный с возникновением дополнительного переменного магн. поля, обусловленного взаимодействием колебаний решетки с электронами проводимости. При этом переменное магн. поле модулирует дипольное взаимодействие между магнитными моментами ядер. В металлах для ядер с большим квадрупольным моментом преобладающую роль играет квадрупольный механизм С.-ф. в., а для ядер с малым квадрупольным моментом могут одновременно участвовать два механизма — квадрупольный и дипольный. С понижением темп-ры T от 300 К до 14 К из-за выморозивания носителей вклад дипольного механизма значительно уменьшается. При квадрупольном механизме возможны переходы между спиновыми уровнями с изменением магн. квантового числа на 2, а при дипольном механизме только на 1.

Интенсивность С.-ф. в. характеризуется элементарной тензора четвертого ранга, связывающими изменения энергии системы спинов с деформацией решетки. Значения элементов тензора С.-ф. в. зависят от конкретных механизмов С.-ф. в. и отражают локальную симметрию внутрикристаллич. поля вблизи данного иона. Элементы тензора С.-ф. в. могут быть определены экспериментально по сдвигу линии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса, а также под действием одноосного давления; по поглощению энергии при АПР; по акустическому насыщению линий ЭПР и ЯМР; по времени спин-решеточной релаксации. Экспериментальное определение констант С.-ф. в. и сопоставление их с теоретич. значениями, соответствующими тем или иным механизмам С.-ф. в., позволяют получать информацию о структуре и величине внутрикристаллич. полей и о динамике спин-решеточных взаимодействий.

Лит.: Альтшутер С. А., Ковырев В. М., Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп, 2 изд., М., 1972; Кеосель А. Р., Ядерный акустический резонанс, М., 1969; Тейер Д., Рэмптоу В., Гилбертук в физике твердого тела, пер. с англ., М., 1978; Магнитная квантовая акустика, под ред. С. А. Альтшутера, М., 1977. В. А. Голенищев-Кутузов.

СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА — проволочная антенна, обычно изготавливаемая из достаточно тонкого провода, свёрнутого в спираль. Подключается к приёмно-передающему тракту с торца или через разрыв в середине спирали. Торцевое подключение удобно для сопряжения с коаксиальными линиями, подключение через разрыв — для сопряжения с двухпроводными линиями передачи. Если размеры С. а. заметно меньше длины волны излучения λ , то характеристики антенны близки к характеристикам элементарного магн. диполя с магн. моментом, направленным вдоль оси спирали. Иногда для увеличения эффективности внутрь спирали вводят ферритовые сердечники, поэтому такие С. а. чаще наз. ферритовыми. Их применяют в приборах НЧ-диапазона, в т. ч. в бытовых радиоприёмниках. В диапазоне СВЧ используют С. а., размер витка к-рых соизмерим с λ . Такие С. а. являются неравномерными антеннами с поверхностными волнами: при работе на первой аксиально несимметричной моде их излучение прижато к оси и циркулярно поляризовано вдоль неё. С. в. применяют как широкополосные антенны осевого излучения (в качестве облучателей зеркальных и линзовых антенн, элементов антенных решёток и т. п.).

Н. М. Цейтлин.

СПИРАЛЬНОСТЬ — квантовое число, равное проекции спина элементарной частицы на направление её импульса. С. (в отличие от проекции спина на произвольную ось квантования) инвариантна относительно Лоренца преобразований, соответствующих скорости, направленной вдоль импульса частицы. Это одна из причин, почему классификация состояний по С. является удобной в релятивистских задачах. С. особенно удобна для классификации состояний безмассовых частиц. С. безмассовой частицы с прожвольным спином принимает только два значения, отвечающих макс. проекции спина по (или против) направлению импульса. Так, для фотона возможные значения С. равны ± 1 , для гравитона ± 2 .

Для электрона возможны С. $\pm 1/2$. При больших энергиях, в том случае, когда можно пренебречь массой частицы со спином $1/2$, знак её С. определяется киральностью состояния. Поскольку в квантовой гродинамике и теории электрослабого взаимодействия киральность фермиона сохраняется в элементарном акте испускания фотона, глюона или промежуточного векторного бозона, то указанная выше связь между киральностью и С. приводит при больших энергиях к полезным законам сохранения и отбора парциал по проекции спина.

М. В. Терентьев.

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ — галактики, в к-рых заметны спиральные ветви; наиб. многочисл. тип наблюдаемых галактик. К С. г. относятся, в частности, Галактика, ближайшими к нам С. г. являются М 31 (туманность Андромеды) и М 33 (туманность Треугольника).

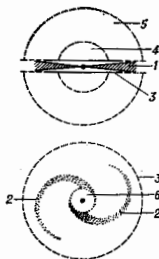
Структура и состав спиральных галактик. В состав С. г. входят звёзды с разл. возрастом и хим. составом, межзвёздный газ и межзвёздная пыль. Общая структура С. г. показана на рис. Плоская составляющая (1) включает молодые звёзды и газопылевую среду и образует слой толщиной неск. сотен парсек, расширяющийся на периферии. Спиральные ветви (2) также принадлежат плоской составляющей. Диск (3) содержит ось, массу звёзд С. г. Изменение сглаженной плотности $\rho(r, z)$ диска с радиусом r и координатой z , перпендикулярной его плоскости, на большом интервале $r_{\text{мин}} < r < r_{\text{макс}}$ обычно следует закону:

$$\rho(r, z) = \rho(0, 0) \exp(-r/r_0) \text{sech}^2(z/z_0).$$

в центре диска, $r_0 \approx 2-5$ кпк — радиальная шкала (характерный размер) диска, $z_0 \approx 0,3-1$ кпк — полутолщина диска; z_0 зависит от дисперсии скоростей звёзд вдоль оси z . Закон $\text{sech}^2(z/z_0)$ описывает распределение плотности в изотермич. самогравитирующем диске. Величина r_0 слабо меняется вдоль z . В искр-ых С. г. на $r_{\text{макс}} \approx (4-6) r_0$ наблюдается «обрыв» резкое падение яркости (плотности) диска. Балдж (4) — внутренняя вып. яркая часть сферической (сфероидальной) составляющей С. г., содержащей старые звёзды с вытянутыми орбитами. Гало (5) — внеш. часть сферы, составляющей; разлучает звёздное гало, имеющее очень низкую яркость, с массой, значительно меньшей массы диска, и «тёмное» гало, масса к-рого в пределах оптич. границ может превышать суммарную массу др. компонент (см. Вращение галактик, Скрытая масса). Ядерная область (6) — выделяющаяся по яркости или структурным особенностям центр. часть С. г. (см. также Ядра галактик). Спектр обычно содержит эмиссионные линии. В ядерной области часто концентрируются молекулярный газ и связанные с ним области звездообразования. Ок. 1% С. г. обладают активными ядрами (сейфертовские галактики). Эти ядра имеют широкие эмиссионные линии, свидетельствующие о быстрых движениях газа, со скоростями в тысячи км/с, высокую светимость (обычно неск. % от интегральной светимости С. г.), шепелювый непрерывный спектр и переменность на разл. масштабах времени.

Содержание газа и звездообразование. Ось, масса межзвёздного газа в С. г. присутствует в двух формах: нейтрального газа (H I) и молекулярного газа (H₂). В большинстве С. г. почти весь газ сосредоточен в пределах оптич. диаметра диска, однако имеется ряд примеров существования протяжённой газовой оболочки вокруг галактик (M81, M83). Масса газа по отношению к интегральной массе С. г. в ср. падает от галактик типа Sc к Sa. Под действием УФ-излучения горячих звёзд газ ионизируется, образуя протяжённые зоны H II, хорошо заметные на фотографиях С. г. Поскольку горячие звёзды высокой светимости являются короткоживущими, светимость С. г. в эмиссионных линиях служит критерием интенсивности звездообразования. Др. наиб. часто используемыми индикаторами интенсивности звездообразования являются показатели цвета (см. Астрофотометрия) С. г., исправленные за межзвёздное покраснение (см. Межзвёздное поглощение), светимость С. г. в УФ-области спектра или в далёкой ИК-области ($\lambda = 10-10^3$ мкм), где излучает пыль, нагреваемая молодыми звёздами. Количеств. оценки интенсивности звездообразования требуют модельных расчётов. Типичные значения массы рождающихся звёзд $\approx 0,01-10 M_{\odot}/\text{год}$ ($1 M_{\odot} \approx 2 \cdot 10^{30}$ кг). В расчёте на единицу массы интенсивность звездообразования уменьшается от галактик Sc к Sa — в соответствии с относит. содержанием газа в этих С. г. Области звездообразования образуют комплексы с характерным размером $\approx 0,5$ кпк. В оси, они сосредоточены в спиральных ветвях С. г.

Спиральные ветви. Наблюдаемые свойства. Спиральные ветви (СВ) представляют области концентрации молодых звёзд и звёздных комплексов, межзвёздного газа, пыли и связанных с газом магн. полей (магн. индукция $\approx 10^{-3}-10^{-4}$ Гс). На фоне звёздного диска СВ выделяются повышенной яркостью и более голубым цветом. Пыль часто образует длинные неровные прожилки, идущие вдоль внутр. кромок СВ, что интерпрети-



тируется как результат существования ударных фронтов в межзвёздной среде. За редким исключением СВ являются закручивающимися, т. е. их концы направлены в сторону, обратную вращению. СВ редко обладают правильной формой, часто они имеют иррегулярные очертания, изломы, ответвления, разрывы. В некоторых случаях СВ сливаются, образуя замкнутые кольца; такие С. г. наз. кольцевыми.

Различают СВ флюккулентные и регулярные. Первые представляют собой совокупности отдельных многочисленных коротких дуг, не продолжающих одна другую. Вторые прослеживаются на большом протяжении, нередко более одного оборота. В этом случае чаще всего наблюдаются две ветви. Обычно ветви С. г. содержат в той или иной пропорции признаки обоих структурных типов.

Механизм образования и поддержания спиральных ветвей. В дифференциально вращающемся диске галактики спиральная структура может быть долгоживущей в двух случаях: когда СВ непрерывно возникают и разрушаются и тогда весь спиральный узор вращается с одинаковой угл. скоростью, в отличие от диска С. г., т. е. не связан с ним жёстко. Первый вариант пригоден для объяснения флюккулентных СВ, к-рые образуются, если в галактиках непрерывно возникают локальные очаги звездообразования. Дифференциальное растягивает их в дуги, пока они не потеряют яркости и не исчезнут с прекращением образования массивных звёзд. Концентрация старых звёзд диска флюккулентные СВ не меняют.

Регулярные СВ рассматриваются как волновые образования в диске [идея принадлежит Б. Линдбладу (В. Lindblad)]. В процессе движения вокруг центра С. г. звёзды и газ периодически проходят через гребни волн. При этом регулярно меняется как плотность, так и скорость их движения. Анализ поля скоростей газа С. г. (а для нашей Галактики — и звёзд) подтверждает волновой характер СВ. Наиб. высокую амплитуду изменения плотности имеет газ, поскольку дисперсия скорости газовых облаков (≈ 10 км/с) в неск. раз ниже, чем звёзд диска, а столкновения газовых масс сопровождаются потерей энергии. Повышение плотности газа в СВ является осн. причиной увеличения интенсивности звездообразования в них.

Разрабатывается неск. подходов к объяснению механизмов возбуждения и поддержания спиральных волн плотности (СВП) в С. г. Возможностью существования СВП как малых возмущений в гравитирующем бесстолкновит. (звёздном) диске впервые была показана в работе К. Лиана (С. Liu) и Ф. Шу (F. Shu). В наиб. простом случае в гидродинамич. приближении для линейных колебаний, описывающих туго закрученные СВ, дисперсионное соотношение имеет вид:

$$m^2(\Omega - \Omega_p)^2 = \kappa^2 - 2\kappa\sigma_0 k + \kappa^2 c_s^2.$$

Здесь $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число, m — мода колебаний (число спиралей), Ω и Ω_p — угл. скорости вращения диска и СВП соответственно, σ_0 — невозмущённая поверхностная плотность диска, c_s — скорость звука или дисперсия скоростей, $\kappa = \sqrt{2\Omega(2\Omega + r d\Omega/dr)}$ — эпиклинич. частота. Роль сил упругости в бесстолкновит. среде играют силы Кориолиса. Знак κ определяет направление вращения спиралей (закручивающиеся или раскручивающиеся СВ). Дисперсионное соотношение даёт два решения для k , соответствующих «коротким» и «длинным» волнам, к-рые отличаются помимо λ направлением распространения. Величина Ω_p для бесстолкновит. газа может иметь значения в интервале $\Omega - \kappa/m < \Omega_p < \Omega + \kappa/m$. Области диска, где реализуются верхние и нижние пределы, наз. соответственно внешним и внутренним лирич./блазовскими резонансами, а область $\Omega = \Omega_p$ — коротцадией. Короткие волны распространяются от коротцадии к резонансам, длинные — в обратном направлении. На резонансах проис-

ходит обмен энергией между волной и звёздным диском. Если внутри резонанса отсутствует волна отражается от центра, при этом может проявиться её усиление. Волновой макс. распространяется радиально со скоростью $\approx c_s$, проходя через диск за $\sim 10^4$ лет. Это обстоятельство, как и затухание СВП при появлении ударной волны в газе, заставляет искать механизмы усиления или возбуждения колебаний. В качестве генератора СВП предлагались вращающийся бар (перемычка), если он имеется в С. г., а также наличие внешнего возмущающего тела (ближнего спутника).

В альтернативном подходе, предложенном А. М. Фридманом, СВП имеют не гравитационную, а гидродинамич. природу и генерируются в результате гидродинамич. неустойчивости в газовом диске, к-рый возмущен в звёздный диск С. г. Колебания возбуждаются в узкой области диска, где велик градиент скорости вращения $\omega(r)$ (вблизи локального максимума кривой вращения). Возникающие при этом СВ имеют закручивающуюся форму, а их число определяется отношением $\Delta\omega/c_s$, где $\Delta\omega$ — перепад скорости. Наблюдения показывают, что локальный максимум на кривой вращения наблюдается в центр. части мл. галактик (напр., Галактика, М 31), хотя и не во всех. По-видимому, единого механизма генерации СВП не существует.

Лит.: Воронцов-Вельяминов В. А., Вигельманская астрономия, 2 изд., М., 1978; Рольфс К. Лекции по теории волн плотности, пер. с англ., М., 1980; K r u t i t s c h v a n d e r, S e a r l e L., Surface photometry of edge-on spiral galaxies, 3. Properties of the three dimensional distribution of light and mass in disk of spiral galaxies, «Astron. and Astrophys.», 1982, v. 119, p. 61; K e p l e r i n c h u t H. G. J., The rate of star formation in normal disk galaxies, «Astrophys. J.», 1983, v. 272, p. 54; F r i d m a n A. M. и др., Centrifugal instability in rotating shallow water and the problem of the spiral structure in galaxies, «Phys. Lett.», 1985, v. 109, A, p. 239; Ф р е м о в Ю. Н. и др., Современные представления о природе спиральной структуры галактик, «УФН», 1989, т. 157, в. 4, с. 599. А. В. Засов.

СПЛАВЫ — макроскопически однородные многокомпонентные системы, в к-рых хотя бы один из компонентов обладает металлич. свойствами. В более широком смысле термин «С.» относят также к полупроводниковым, оксидным, солевым, органическим и др. многокомпонентным системам (см. *Гиббса правило фаз*). Обычно С. находятся в кристаллич. состоянии, однако некие из них могут быть получены в аморфном состоянии (напр., *металлические стекла*).

С. подразделяются на одофазные (гомогенные) и многофазные (гетерогенные). Среди отд. *фаз* в С. различают: *твёрдые растворы*, в к-рых атомы или ионы компонентов, смешиваясь в произвольных соотношениях, образуют общую кристаллич. решётку, характерную для одного из компонентов; *интерметаллические соединения*, для к-рых характерно определ. соотношение между составляющими их элементами и кристаллич. решётки к-рых отличны от решёток образующих их элементов. Для нек-рых групп С. используют традиц. названия: чугуны и стали (Fe — C), латуни (Cu — Zn), бронзы (Cu — Sn).

Классификация. Кроме классификации С. по числу фаз, находящихся в равновесии, С. различают по характеру диаграмм состояния (твёрдые растворы, эвтектик. С., эвтектоидные С., перектич. С. и др.; см. *Диаграмма состояния*), по осн. компоненту (ферросплавы, медные С. и т. п.) или по двум осн. компонентам (*железо-углеродистые С., медно-никелевые С. и т. п.*), а также по осн. свойству или названию (магн. С., сверхпроводящие С. и т. п.).

Наиб. последовательна классификация С. по степени упорядочения атомов: жидкий или аморфный С. (отсутствует и дальний и ближний порядок в расположении атомов разного сорта); неупорядоченные твёрдые растворы замещения; твёрдые растворы замещения с ближним порядком; твёрдые растворы внедрения; кристаллич. фаза с упорядоченным распределением атомов, когда атомы компонентов С. образуют неск. связанных друг в друга кристаллич. подрешёток.

Термодинамическое описание. В качестве независимых термодинамических переменных системы рассматривают обычно темп-р T и состав — кол-во молей компонентов (n_1, n_2, \dots, n_i) или их молярные доли $x_i = n_i/\Sigma n_i$. Введен давление p принимают постоянным и равным 1 атм $= 1,013 \cdot 10^5$ Па. Характеристич. ф-нциями служат *энthalпия* H , *энтропия* S и *Гиббса энергия* $G = U - TS - pV$ (внутри энергии, V — объём). Для описания компонентов S используют парциальные молярные величины, напр. *химический потенциал* $\mu_i = \partial G/\partial n_i$. Относительные парциальные молярные величины описывают различие между парциальной молярной величиной i -го компонента S и молярной величиной для того же компонента в виде чистого вещества. Относительные парциальные молярные величины наз. *энthalпийной H^M , энтропийной S^M и энергией Гиббса G^M смещения*, напр.:

$$H_i^M = \bar{H}_i - H_i^0, \quad (1)$$

где индекс «0» относится к чистому i -му компоненту.

В термодинамике S особое значение имеют относительные интегральные молярные величины H^M, S^M, G^M , напр. относительная интегральная молярная энthalпия (теплота смещения):

$$H^M = \sum_i x_i H_i^M. \quad (2)$$

Это тепло, к-рое необходимо затратить, напр., для образования одного моля сплава из x_i молей чистого вещества A и x_i молей чистого вещества B (т. е. величина, непосредственно измеряемая калориметрически). Условно образования S : $H^M < 0$, что возможно, когда силы притяжения между атомами равного сорта преобладают над силами отталкивания (при $T = 0K$). Урния типа (2) для относительных интегральных молярных величин справедливы как для гомогенных, так и для гетерогенных S . Фазовый состав S в зависимости от T и x описывается диаграммой состояния, число фаз S , сосуществующих в равновесии, определяется правилом фаз Гиббса.

Микроскопическое описание сплавов базируется на одноэлектронной модели твёрдого тела. Осн. задачи микроскопич. теории — расчёт диаграмм состояния, термодинамич. ф-ций, кинетики, упорядочения и т. п. Расчёты из первых принципов, когда в качестве параметров входят только ат. номера и массы атомов, возможен лишь в немногих случаях. В феноменологич. теориях рассматривают ряд факторов, влияющих на структуру и свойства S : различие размеров атомов и их валентностей, перераспределение заряда между атомами равного сорта, взаимодействие Ван-дер-Ваальса между ионными остовами (см. *Межатомное взаимодействие, Межмолекулярное взаимодействие*).

В эмпирич. правилах У. Юм-Розери (W. Hume-Rothery) сформулированы нек-рые закономерности, связывающие роль этих факторов с особенностями структуры S : 1) если различие в атомных радиусах $\geq 15\%$, то взаимная растворимость компонентов ограничена; 2) равная валентность благоприятствует образованию интерметаллич. соединений и сужает область существования твёрдых растворов; 3) при нек-рых отношениях числа валентных электронов к числу атомов образуются т. н. электронные соединения с определ. типами кристаллич. решёток (фазы Юм-Розери).

Получение сплавов. Осн. метод — *кристаллизация* по расплаву. Перспективна направленная кристаллизация, при к-рой в кристаллизующемся S искусственно создаётся градиент темп-р, что даёт возможность управлять микроструктурой S . (см. *Металлофизика*). Быстрая кристаллизация — охлаждение распла-

ва со скоростью порядка 10^6 K/с позволяет фиксировать метастабильные фазы в S , в частности *сферообразные состояния*. К аналогичным результатам приводят сверхбыстрая закалка и распыление, когда мелкие капли расплава S охлаждаются на холодной поверхности или в потоке холодного инертного газа.

В металлургии. Этот метод обычно используют S сплавят при $T < T_{пл}$. Этот метод обычно используют для получения S из тугоплавких компонентов (W, Mo, Ta и др.). В т. н. методе горячего и з. с. г. а. т. и. ч. при с. с. в. а. и. я. порошки одновременно подвергают воздействию высоким давлений и темп-р. Для получения тонких плёнок и слоёв S применяют методы конденсации из паровой фазы, электроосаждения из раствора, диффузионного насыщения и т. п.

Фазовые превращения. При изменении темп-р, давления или под действием магн. поля в S могут происходить *фазовые переходы*, при к-рых имеет место изменение кристаллич. структуры, хим. состава и, как правило, физ. свойств (см., напр., *Алмаз и Углерод, Мартенситное превращение*). Изменение структуры, не сопровождающееся изменением состава, характерны для полиморфных превращений в S . (см. *Полиморфизм*) и упорядочения твёрдых растворов. Изменение хим. состава без изменения типа кристаллич. решётки имеет место при раслинии (с и в о д а л ь н о м р а с п а д е н и я) твёрдых растворов. В большинстве случаев при фазовых превращениях одновременно меняются и структура и состав S .

Фазовые превращения в S (в твёрдом состоянии) являются фазовыми переходами 1-го и 2-го рода. Мерой отклонения от термодинамич. равновесия, или термодинамич. движущей силой фазовых превращений, при постоянных темп-ре и давлении является уменьшение энергии Гиббса G ; изменение G в точке фазового перехода достигается либо путём появления в результате флуктуации малых областей (зародыши) новой фазы с заметным отличием её структуры и свойств от структуры и свойств исходной фазы (при фазовом переходе 1-го рода), либо путём бесконечно малых изменений структуры и свойств во всём объёме (при фазовом переходе 2-го рода). Большинство фазовых превращений в S являются фазовыми переходами 1-го рода, в процессе к-рых возникает гетерогенное состояние. На *кинетику фазовых переходов* в S существ. влияние оказывают *дислокации*, границы зёрен и др. *дефекты* кристаллич. структуры.

Свойства сплавов. Различают структурно-чувствительные свойства, зависящие только от состава и типа кристаллич. решётки, и структурно-чувствительные, к-рые, кроме того, зависят от реальной структуры S (т. е. концентрации разл. дефектов). Механич. свойства (*пластичность, упругость*) гораздо сильнее зависят от реальной структуры, чем электронные (электрич., магн., оптич. и др. свойства, определяемые электронной системой). Как правило, структурно-чувствительные свойства гомогенных S аддитивны, а структурно-чувствительные отклоняются от аддитивности.

Отличие кинетики свойств S от свойств чистых металлов проявляется в виде примесных вкладов в электропроводность, теплопроводность и др. Для сопоставления S справедливо *Маттиссена правило*: $\rho = \rho_r + \rho_{ст}$, где ρ_r обусловлено рассеянием электронов на фонах (зависит от темп-ры T), $\rho_{ст}$ — остаточное сопротивление, зависящее от состава S (рис. 1). Величина $\rho_{ст}$ растёт пропорционально квадрату функции валентностей ΔZ компонентов S . (рис. 2). Для разбавленных S . неметалл. металлов с переходными и редкоземельными металлами характерно появление минимума сопротивления при низких темп-рах (см. *Криодоэффект*).

В отличие от сверхпроводящих металлов, для к-рых характерно наличие одного критич. поля H_c (при $H = H_c$ магн. поток полностью проникает в ме-

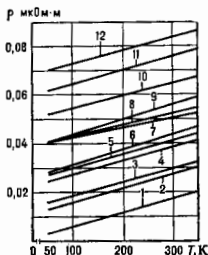


Рис. 1. Температурные зависимости удельного сопротивления сплавов Cu типа твердых растворов: 1) чистый Cu; 2) Cu — In (1,03%); 3) Cu — Ni (1,12%); 4) Cu — Sb (0,4%); 5) Cu — Sn (0,80%); 6) Cu — Ni (2,18%); 7) Cu — Mn (1,2%); 8) Cu — Fe (0,61%); 9) Cu — Ni (3,32%); 10) Cu — Fe (0,87%); 11) Cu — Sb (1,13%); 12) Cu — Au (1,01%).

талл), сверхпроводящие С. являются *сверхпроводниками второго рода*, т. е. имеют 2 критич. поля (при $H = H_{c1}$ начинается проникновение магн. поля в С., при $H = H_{c2} \gg H_{c1}$ С. полностью переходит в нормальное состояние). Критич. темп-ра T_c и критич. поля H_{c1} и H_{c2} не зависят от реальной структуры С., в то время как величина критич. плотности тока J_c сильно зависит от параметров реальной структуры.

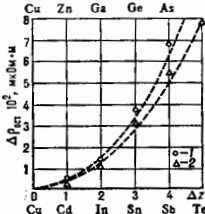


Рис. 2. Остаточное сопротивление $R_{ост}$ на 1% атомных концентраций примесей. Для верхней кривой $\Delta R_{ост} = 0,4(\Delta Z)$; для нижней кривой $\Delta R_{ост} = 0,32(\Delta Z)$.

Магн. свойства С. разнообразны. В некоторых С. реализуется ферромагн. состояние (см. *Ферритизация*), другие являются неупорядоченными магнетиками — *спиновыми стеклами*. Мн. свойства ферромагнитных С. (*коэрцитивная сила*, остаточная индукция, *магнитная проницаемость* и др.) структурно-чувствительны и зависят от фазового состава С., размеров и формы кристаллов, *текстуры*, плотности дислокаций и др. дефектов.

Специфическими для С. процессами переноса являются диффузия (движение атомов в направлении, обратном градиенту концентрации) и электроперенос (направленное перемещение атомов под действием пост. электр. тока). Осн. механизм — обмен местами атомов и вакансий.

Особенности механич. свойств С. обусловлены различием упругих свойств образующих их фаз (изменение электронной структуры, образование межатомных связей для металлов кристаллич. решеток и т. д.), а также протеканием фазовых превращений под действием механич. напряжений и др. В С. наблюдаются эффекты упрочнения в результате закрепления *дислокаций* на примесных атомах и торможения их движения, выделения частиц 2-й фазы и т. д. В условиях деформации под действием пост. нагрузки (ползучесть) при движении дислокаций со скоростью, превращающей скорость диффузии примесных атомов, имеет место отрыв дислокаций от атмосферы примесей (атмосферы Коттрелла), при замедлении дислокаций они вновь захватываются атмосферой примесей (деформат. старение), что приводит к изменению пластичности и прочности. В эвтектидных С. при определенных температурно-скоростных условиях деформации наблюдается явление *сверхпла-*

стичности — резкое падение сопротивления деформации, возрастание пластичности, отсутствие упрочнения (см. *Мезамеханические свойства*).

Экспериментальные методы исследования сплавов разделяются на структурные, физические и механические. К структурным методам относятся оптич. микроскопия в рассеянном или поляризов. свете (металлография), электронная микроскопия, рентг. микроскопия, автономная микроскопия (см. *Ионный проектор*) и др. Для фазового анализа используют дифракц. методы (*рентгенография материалов, нейтронная графия, электронная графия*). Физ. методы необходимы для построения диаграмм состояния С., изучения фазовых превращений, процессов упорядочения и т. п. Наиб. распространены измерения сопротивления, *магнитной восприимчивости*, внутреннего трения и др. при высоких темп-рах. Для изучения диффузии служат в осн. радионуклиды. Для исследования электронной и магн. структуры С. применяют методы *рентгеновской спектроскопии, Мессбауэровской спектроскопии* и др.

Лит.: Progress in material science, т. 1—32; N. Y. — Oxi.: 1949—80; *Большая энциклопедия*, т. 1—8; N. Y. — Oxi.: 1949—80; Вагнер К., Термодинамика сплавов, пер. с англ., М., 1957; Делленгер У., Теоретическое металловедение, пер. с нем., М., 1960; Физическое металловедение, пер. с англ., 3 изд., т. 1—3, М., 1987; Пирсон С. У., Кристаллохимия и физика металлов и сплавов, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1977; Уманский Я. С., Сняков Ю. А., Физика металлов, М., 1978; Пасынков В. В., Сорokin И. В. С., Материалы электронной техники, 2 изд., М., 1985; Циммерман Р., Гровер К., Металлургия и материаловедение. Справочник, пер. с нем., М., 1982; Физическое материаловедение в СССР. История, современное состояние, перспективы развития, К., 1986, В. А. Физика.

СПЛОШНОЕ СПЕКТР (непрерывный спектр) — спектр эл.-магн. излучения, распределение энергии в к-ром характеризуется непрерывной ф-цией частоты ν излучения $f(\nu) = f(\lambda)$ — вид длины его волны λ — функцией $f(\lambda)$ (см. *Спектры оптические*). Для С. с-ция $f(\nu)$ [или $f(\lambda)$] слабо изменяется в достаточно широком диапазоне ν (или λ), в отличие от линейчатых и полосатых спектров, когда $f(\nu)$ имеет при дискретных значениях частоты $\nu = \nu_1, \nu_2, \dots$ выраженные максимумы, очень узкие для спектральных линий и более широкие для спектральных полос. В оптич. области при разложении света спектральными приборами С. с. получается в виде непрерывной полосы (при визуальном наблюдении или фоторегистрации) или плавной кривой (при фотозелитрич. регистрации). С. с. наблюдаются как в испускании, так и в поглощении. Примером С. с., охватывающего весь диапазон частот и характеризующего спектральным распределением энергии, описываемым *Планком законом излучения*, служит спектр излучения абсолютно черного тела.

В нек-рых случаях возможны наложения линейчатого спектра на сплошной. Напр., в спектрах Солнца и звезд на С. с. испускания могут накладываться как дискретный спектр поглощения (*фраунгоферовы линии*), так и дискретный спектр испускания (в частности, спектральные линии испускания атома H).

Согласно квантовой теории, С. с. возникает при *квантовых переходах* между двумя совокупностями уровней энергии, из к-рых по крайней мере одна принадлежит к непрерывной последовательности уровней. Примером может служить С. с. атома H, получающийся при переходах между дискретными уровнями энергии с разл. значениями гл. *квантового числа n* и непрерывной совокупности уровней энергии, лежащих выше границ ионизации (свободно-связанные переходы); в поглощении С. с. соответствует ионизация атома H (переходы электрона из связанного состояния в свободное), в испускании — рекомбинация электрона и протона (переходы электрона из свободного состояния в связанное). При переходах между равными парами уровней энергии, принадлежащими к непрерывной совокупности уровней (свободно-свободные переходы), также возникает С. с., соответствующий термодинамическому излучению при испускании и обрат-

му процессу при поглощении. Переходы же между равными парам дискретных уровней энергии со-
опадают линейчатый спектр (связанно-связанные
переходы).

С. с. многоатомных молекул могут получаться при
переходах между совокупностями близких дискретных
уровней энергии в результате наложения очень большо-
го числа спектральных линий, имеющих конечную
плотность. В таком случае при недостаточной разре-
шающей способности применяемых спектральных при-
боров линейчатые или полосатые спектры могут сли-
ваться в С. с. М. А. Ельшиевич.

СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР — разновидность
радиоактивного распада тяжёлых ядер (С. с. Радиоак-
тивность). Впервые обнаружена у ядер природного
урана Г. Н. Флёровым и К. А. Петрижаком в 1940. С. д.
я., подобно альфа-распаду, происходит путём тун-
нельного перехода. Вероятность С. д. я. экспоненци-
ально зависит от высоты барьера деления.
Для изотопов U и соседних с ним элементов высота барь-
ера деления ~6 МэВ. При небольших (~МэВ) вари-
ациях высоты барьера период С. д. я. изменяется в 10^{30}
раз (см. рис. 5 в ст. Деление ядер).

С. д. я. является доминирующим каналом распада
сверхтяжёлых ядер, вследствие чего именно
этим процессом определяется возможность существова-
ния ядер с большим массовым числом A, т. е. граница
периодов системы элементов (см. Трансураниевые эле-
менты). Для U и Pu характерно асимметричное (по
массе осколков) деление; по мере роста A оно прибли-
жается к симметричному (Fm).

Лит. см. при ст. Деление ядер.

СПОНТАННОЕ ИСПУСКАНИЕ (спонтанное излу-
чение) — процесс самопроизвольного испускания эл-
магн. излучения атомами и др. квантовыми системами,
находящимися на возбуждённых уровнях энергии (см.
Квантовый переход). В отличие от вынужденного излу-
чения, С. и. не зависит от воздействия на квантовую
систему внеш. излучения, и его закономерности опре-
деляются исключительно свойствами самой системы
(подобно др. типам спонтанных процессов — радиоак-
тивному распаду, превращению молекул при мономолекулярных
реакциях и др.).

С. и. возникает при спонтанном квантовом переходе
возбуждённой системы с более высокого уровня энер-
гии ϵ_i на более низкий ϵ_k и характеризуется частотой
 ν_{ik} испускаемого фотона с энергией $h\nu_{ik} = \epsilon_i - \epsilon_k$
и вероятностью A_{ik} , равной ср. числу фотонов, испус-
каемых квантовой системой в единицу времени (см.
Эйнштейна коэффициенты). Если населённость уров-
ня ϵ_i равна N_i , то мощность С. и. (энергия фотонов,
испускаемых в 1 с) равна $N_i A_{ik} h\nu_{ik}$, она определяется
интенсивностью С. и., к-рая остаётся постоянной при посто-
янстве N_i . Если задана нач. населённость i-го уровня
 N_{i0} , а дальнейшее возбуждение отсутствует, то вследст-
вие С. и. N_i будет убывать со временем t по закону:

$$N_i = N_{i0} \exp(-A_i t), \quad \text{где } A_i = \sum_k A_{ik} - \text{полная ве-}$$

роятность С. и. при переходах системы с уровня энер-
гии ϵ_i на все более низкие уровни энергии ϵ_k . Чем
больше A_i , тем быстрее затухает со временем С. и. я
тем меньше время жизни $\tau_i = 1/A_i$ на уровне ϵ_i .

Вероятность A_{ik} С. и., являющаяся важнейшей ха-
рактеристикой квантового перехода, зависит от ха-
рактеристики уровней, между к-рыми происходит переход.
Для дипольного излучения A_{ik} пропорциональна кубу
частоты перехода и квадрату дипольного момента пере-
хода; в видимой области спектра она $\sim 10^8$ с⁻¹, что со-
ответствует временам жизни возбуждённых уровней
энергии $\sim 10^{-8}$ с. В спектроскопии часто пользуются
вместо вероятностей A_{ik} безразмерными вероятностя-
ми $f_{ik} = A_{ik}/A_i$, т. е. силами осцилляторов (A_0 —
вероятность, принятая за 1 и дающая такой же закон

затухания С. и., как и для дипольного излучения упруго-
связанного электрона согласно классич. теории).

Лит. см. при ст. Излучение. М. А. Ельшиевич.
СПОНТАННОЕ НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ — ча-
стичная или полная потеря системой имеющейся в
ней симметрии, выражающаяся в том, что энергетиче-
ски или термодинамически наиб. выгодные состояния
системы обладают меньшей симметрией, чем у-рия, её
описывающие, причём преобразования симметрии
переводят эти состояния друг в друга. Примером систе-
мы со С. н. с. может служить изотропный ферромагнет-
ик, состоящий из локализов. спинов. Такая система
инвариантна относительно трёхмерных вращений, т. е.
преобразования из группы SU(3); вместе с тем её энер-
гия становится минимальной, когда все спины выстраи-
ваются в одном (произвольном) направлении. Если это
происходит, то в системе появляется ненулевой маг-
нет. м. и остаётся инвариантность относительно враще-
ний лишь в плоскости, ему ортогональной. Т. о., SU(3)-
симметрия системы нарушается до SU(2)-симметрии.

Идея о возможности С. н. с. восходит к Л. Д. Ландау,
к-рый отметил в качестве особой черты фазовых перехо-
дов 2-го рода возникновение в точке перехода нового
типа симметрии (см. Ландау теория); эту идею можно
сформулировать и в др. форме: при фазовом переходе
спонтанно нарушается симметрия системы.

Известно большое число примеров С. н. с. В теории
конденсированного состояния к ним можно отнести
явления ферромагнетизма, сверхтекучести и сверхпро-
водимости, в теории элементарных частиц — модели
электрослабого взаимодействия.

Математически корректный способ описания С. н. с.,
пригодный как для квантовой теории поля (КТП), так
и для классич. и квантовой статистик, был предложен
К. Н. Боголюбовым в 1960 и носит назв. метода
квазисредних. Идея метода заключается в следующем.
Система подвергается воздействию внеш. поля, нару-
шающего её симметрию, после чего поле устремляется
к нулю. Т. к. внеш. поле нарушает симметрию системы,
и в ней может возникнуть ненулевое среднее от величин,
инвариантных относительно группы симметрии
невозмущённой системы. Если при стремлении внеш.
поля к нулю это среднее не обращается в нуль, то го-
ворят, что в системе имеется спонтанное среднее
(или конденсат), нарушающее симметрию. Т. о. симмет-
рия системы понижалась и в системе возник *дальний и
близкий порядки*, характеризующийся *параметром
порядка* (как правило, совпадающий с отличным от нуля
квазисредним).

В КТП, где все усреднения проводятся по осн. со-
стоянию системы, или вакууму, эффект С. н. с. соответст-
вует эффекту *вырождения вакуума*. Группой, до к-рой
нарушается симметрия, является подгруппа группы
симметрии, переводящая вакуум в себя, а все вакуумные
теории параметризуются элементами фактор-пространст-
ва (дополнит. пространств) группы симметрии по
подгруппе, до к-рой нарушается симметрия. Включение
внеш. поля, нарушающего симметрию системы до
группы инвариантности вакуума, полностью снимает
вырождение, и усреднение проводится по единств. осн.
состоянию, причём при стремлении внеш. поля к нулю
это состояние стремится к одному из вакуумов невозмур-
ждённой теории. Т. о., применение метода квази-
средних в КТП сводится к выбору осн. состояния, по к-рому
проводятся усреднения, а инвариантность ненулевых
спонтанных средних (см. Вакуумный конденсат)
относительно группы симметрии системы является следст-
вием неинвариантности вакууму по отношению к
этой группе.

В случае, когда нарушается непрерывная симметрия,
в системе существуют флуктуации, представляющие со-
бой колебания спонтанного среднего в направлениях,
отвечающих его изменениям под действием группы сим-
метрии. Те флуктуации, к-рые при стремлении их ха-
рактерных размеров к бесконечности происходят без увели-

чения энергии, наз. *голдстоуновскими модами*. Кол-во гольдстоуновских мод равно размерности фактор-пространства группы высокой симметрии по подгруппе низкой (остаточной) симметрии. В КТП гольдстоуновским модам соответствуют элементарные возбуждения, или *квазичастицы* с бесцеленым спектром — безмассовые гольдстоуновские частицы (*голдстоуновские бозоны, гольдстоуновские фермионы*). Утверждение о том, что в КТП со спонтанно нарушенной непрерывной симметрией имеются безмассовые частицы, наз. *Гольдстоуна теоремой* (в релятивистской теории многих тел это утверждение доказано Н. Н. Боголюбовым и наз. теоремой о $1/q^2$; см. *Боголюбова теорема*). При нарушении дискретной симметрии гольдстоуновские моды, естественно, не появляются.

Анализ возможности С. ч. с. часто начинают с нахождения классич. решений, минимизирующих гамилтониан. Если для таких решений имеется вырождение, то говорят о нарушении симметрии на классическом уровне. При этом может оказаться, что учёт флуктуаций приведёт к обращению спонтанных средних в нуль. Поскольку флуктуации уменьшаются с ростом числа степеней свободы, их роль возрастает в системах с низкой размерностью причём наиб. сильными являются длинноволновые гольдстоуновские флуктуации, т. е. они сопровождаются очень малым увеличением энергии. Всё это приводит к тому, что спонтанное нарушение непрерывной симметрии возможно лишь в системах размерности выше двух (см. *Мёрмина — Валкера теорема*). В одно- и двумерных системах спонтанное нарушение непрерывной симметрии на классич. уровне сопровождается бесконечно большими гольдстоуновскими флуктуациями и симметрия восстанавливается. При этом в двумерных системах дискретная симметрия может нарушаться, как это происходит, напр., в *Изинга модели*. В одномерных системах даже флуктуации с несмещающей в ДВ-пределе энергией становятся достаточно сильными для того, чтобы восстановить любую нарушенную симметрию. Механизм восстановления дискретной симметрии в одномерных системах состоит в том, что система становится термодинамически выгодно разбиться на участки малого размера (домены) со всевозможными допустимыми значениями спонтанного среднего, что приводит к восстановлению симметрии.

В случае, когда непрерывная симметрия в системе из-за взаимодействия с *калибровочным полем* становится локальной (т. е. допускает преобразования, зависящие от координат), её нарушение не сопровождается появлением гольдстоуновских мод, т. к. в данной ситуации гольдстоуновские моды являются чисто калибровочными, т. е. нефизическими. Однако соответствующие комбинации калибровочных полей могут приобретать массу и становятся наблюдаемыми, как, напр., промежуточные векторные бозоны в стандартной теории *электрослабого взаимодействия*. Этот эффект наз. *эффектом Хиггса*, а механизм, к нему приводящий, — *Хиггса механизмом*.

Отметим, что С. ч. с. в КТП не следует связывать с нарушением симметрии из-за возникновения *аномалий*: аномалии появляются вследствие невозможности инвариантной регуляризации классич. гамилтониана, и поэтому данное нарушение симметрии обусловлено лишь тем, что квантовый гамилтониан обладает более *низкой симметрией* по сравнению с классическим.

Лит.: Боголюбов Н. Н., Квансредние в задачах статистической механики, 2 изд., Дубна, 1963; Пятаев В. и др. в кн. А. З. Поляков и В. Л. Фукс, *Фазовая теория фазовых переходов*, 2 тал., М., 1982; Коуди мен С., Тайная симметрия: введение в теорию спонтанного нарушения симметрии и калибровочные поля, в сб.: *Квантовая теория калибровочных полей*, пер. с англ., 1977; Восток В. П. и др., Спонтанное нарушение симметрии, калибровочные теории, механизм Хиггса и т. п., там же; Грэнб А. А., Проблема неинвариантности вакуума в квантовой теории поля, М., 1978; Восток В. П. и др. в кн. Н. В. Шарк и др. В. В. Калашникова, М., 1980; В. П. Шестер.

СПОНТАННОЕ НАРУШЕНИЕ СУПЕРСИММЕТРИИ — осуществляется в ситуациях, когда гамилтониан

теории суперсимметричен, а основное (вакуумное) состояние (см. *Вакуум* в квантовой теории поля) не является скаларом относительно преобразований *суперсимметрии*. В теориях глобальной суперсимметрии необходимым и достаточным фаз. условием С. ч. с. является отличие от нуля и положит. значение энергии вакуума. Простым мате. критерием С. ч. с. является отличие от нуля *вакуумного среднего* от вакуум. поля (F, D). Гольдстоуновским полем, сопровождающим С. ч. с., является безмассовое спиновое фермионное поле (см. *Гольдстоуновский фермион*, *Спонтанное нарушение симметрии*). Соответствующая безмассовая спиновая частица должна фигурировать в спектре фаз. состояний.

В теориях *супергравитации* С. ч. с. обязательно сопровождается отличием от нуля энергии вакуума. Гольдстоуновская частица в супергравитации смешивается с *гравитино*, что приводит к возникновению массивного поля гравитино и исчезновению безмассовой спиновой частицы из спектра состояний. М. В. Терентьев.

СПУСКОВАЯ СХЕМА — электр. устройство с двумя устойчивыми состояниями равновесия, к-рое под действием внешнего импульсного сигнала переходит из исходного состояния равновесия в другое и сохраняет это новое состояние равновесия после прекращения внеш. воздействия.

Обычно С. с. строятся на биполярных или полевых транзисторах (см. *Триггер*, *Полевой транзистор*, *Транзистор биполярный*). С. с. также может быть построена с помощью нелинейного элемента (рис. 1), вольт-ампер-

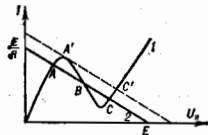
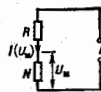


Рис. 1. Спусковые схемы на нелинейном элементе. $I(U)$ — активное сопротивление, N — нелинейный элемент с падающим участком вольт-амперной характеристики.

Рис. 2. I — вольт-амперная характеристика нелинейного элемента $I(U_n)$ с падающим участком. $E + U_y = U_n/R$ при $U_y = 0$.

ная характеристика k -рого содержит падающий участок. Ур-ние, определяющее состояние равновесия системы, имеет вид:

$$E + U_y = RI(U_n) + U_n,$$

где U_n — напряжение на нелинейном элементе, $I(U_n)$ — ток, протекающий в цепи, E — пост. напряжение питания, U_y — внешнее управляющее напряжение. График. решение этого ур-ния показано на рис. 2. Параметры подобраны так, что в отсутствие управляющего напряжения ($U_y = 0$) система имеет три состояния равновесия (A, B и C). Состояния на нарастающих участках характеристики (A и C) являются устойчивыми, а состояние на падающем участке (B) неустойчиво: под действием сколь угодно малых флуктуаций система переходит из этого состояния в одно из устойчивых состояний.

Пусть исходным состоянием системы является состояние A . При появлении положительного нарастающего управляющего напряжения ($U_y > 0$) напряжение U_n и ток I нелинейного элемента возрастает до тех пор, пока не достигнут начала падающего участка характеристики (состояние A). Дальнейшее увеличение напряжения на нелинейном элементе вызывает уменьшение тока в цепи и, следовательно, уменьшение падения напряжения на резисторе R . Это приводит к ещё большему возрастанию напряжения U_n , падению тока I и т. д. Т. о., в системе развивается лавинообразный

процесс, к-рый скачком переводит систему в состояние S на другом нарастающем участке характеристики. После уменьшения управляющего напряжения до нуля система остаётся в устойчивом состоянии S . Обратный переход системы в состояние A происходит аналогичным образом при воздействии отрицательного управляющего напряжения ($U < 0$). В реальных S . с. переход между устойчивыми состояниями происходит за конечное время, к-рое определяется бистабильностью нелинейного элемента и паразитными индуктивностями и ёмкостями схемы.

Нелинейным элементом в S . с. могут служить туннельные диоды, четырёхслойные полупроводниковые диоды и др. устройства, имеющие падающий участок вольт-амперной характеристики. S . с. применяются в устройствах автоматики, измерит. и вычислит. техники для запоминания и хранения информации. В совр. аппаратуре преим. используют триггеры на транзисторах и интегральные микросхемные триггеры (см. *Логические схемы*). S . с. также называют устройства, имеющие больше двух устойчивых состояний (напр., параметров) или одно устойчивое и одно метастабильное состояние (см. *Одновибратор*).

А. В. Степанов.

СРЕДНЕГО ПОЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЕ (*молекулярное поле*, эффективное поле) — один из методов приближённого описания эффектов многочисленных взаимодействий в задачах многих тел в квантовой механике и квантовой статистике. С. п. п. применяется в тех случаях, когда точное решение задачи отсутствует, а учёт конечного числа членов ряда возмущений теории недостаточен (напр., если константа взаимодействия не мала или ряды теории возмущений обладают плохой сходимостью). С. п. п. состоит обычно из эфф. «линеаризации» гамма-функции взаимодействия мя. частиц, т. е. в замене его соответственно подобранным гамма-тоном одночастичного взаимодействия с нек-рым эфф. «полем»; параметры к-рого следует определить самосогласованным образом. Физически такая замена соответствует переходу от «взаимодействия» к «ядьловому действию», т. е. к достоянному (не зависящему от расстояния) многочастичному взаимодействию с формально бесконечным радиусом, а также пренебрежению коррелл. эффектами. Несмотря на такое упрощение решения задачи мя. тел S . п. п. в большинстве случаев качественно правильно описы-

вает физ. свойства очень широкого класса реальных систем мя. тел, в первую очередь сложных атомов, молекул, жидкостей и твёрдых тел (см. *Самосогласованное поле*, *Хартри* — *Фока метод*).

Особенно важное значение С. п. п. имеет для решения задач физики конденсиров. состояния, прежде всего для описания разл. подсистем в твёрдых телах (столбец 1 в табл.), испытывающих разнообразное *фазовое переходы* (структурные, ориентационные, магнитные, сверхпроводящие и т. п. — столбец 2 в табл.). В подобных системах среднее поле (СП) принимается обычно пропорциональным *параметру порядка* (столбец 3 в табл.), т. е. ср. значению оператора u по порядку i и j (оператор, описывающий динамическую переменную, испытывающую упорядочение). Физически это означает пренебрежение квантовыми флуктуациями этого оператора и построением на них высших *корреляционными функциями*. При этом СП оказывается зависящим от внем. полей, темп-ры и др. интенсивных термодинамич. параметров (для структурно упорядоченных систем СП может быть неоднородным, т. е. зависеть от координат). С. п. п. позволяет вычислить *статистическую сумму* и все термодинамич. ф-ции системы. Дальнейшая процедура самосогласования приводит обычно к достаточно простому ур-нию (в большинстве случаев — трансцендентному, иногда, как в случае сверхпроводника, — интегральному) для параметра порядка. Это ур-ние имеет нетривиальные (отличные от нуля) решения лишь если определ. темп-ры T_K , называемой *критической точкой* или *точкой фазового перехода 1-го или 2-го рода*. При этом значение энергии взаимодействия системы со СП в осн. состоянии при $T = 0$ составляет величину порядка kT_K .

Физ. смысл СП столь же разнообразен, сколь разнообразны виды систем и параметров порядка; как правило, СП определяется проведением параметра порядка на ср. энергию взаимодействия частиц системы. Так, в магнитоупорядоченных веществах (в т. ч. *спиновых стёклах*) и *сегнетоэлектриках* это — обменное взаимодействие, в сверхпроводниках — электрон-фононное взаимодействие, в *переходах металлов — диэлектриков* — внутратомное кулоновское отталкивание между электронами, в классич. газах и жидкостях — межмолекулярное притяжение и т. п. До возникновения микроскопич. описания С. п. п. вводилось

Физический объект	Фазовый переход	Параметр порядка	Автор, год открытия
1	2	3	4
1. Классический идеальный газ	Конденсация (газ—жидкость)	Однородная средняя плотность	И. Д. Ван-дер-Ваальс, 1873
2. Классическая жидкость	Кристаллизация (жидкость—твёрдое тело)	Неоднородная средняя плотность (фурье-компоненты)	Дж. Ленард-Джонс, А. Дежоншир, 1937
3. Жидкий кристалл	Ориентация осей молекул	Среднее значение $\langle \cos^2\theta - 1 \rangle$ θ — угол между осью молекулы и директором	Дж. Майер, А. Соуп, 1958
4. Ферромагнетики (диэлектрик, металл)	Парамагнетизм—ферромагнетизм	Спонтанная намагниченность. Равность чисел электронов с противоположно ориентированными спинами	Б. Л. Ролинг, 1892; П. Вейс, 1907; Э. Стовер, 1938
5. Антиферромагнетик, феррит	Парамагнетизм—антиферро- (или ферри-) магнетизм	Спонтанная намагниченность подрешетки	Л. Неель, 1932; Л. Д. Лавдау, 1933
6. Спиновое стекло	«Саморазваливание» локальных маг. моментов	Параметр Эдварда—Андерсона	Д. Лиерингтон, С. Кирпатрик, 1975
7. Сегнетоэлектрик	Пара—сегнетофаза	Спонтанная поляризация	В. Л. Гинзбург, 1945; А. Дежоншир, 1949
8. Бинарный сплав	Порядок—беспорядок	Равность чисел атомов одного типа в своих и чужих положениях	У. Брэгг, Е. Вильямс, 1934
9. Моттовский диэлектрик	Образование щели в спектре электронов	Снижон числа электронов на уровне Ферми	Н. Мотт, 1956; Дж. Хаббард, 1959
10. Сверхпроводник	Нормальный металл—сверхпроводник	Энергетическая щель в центре электронов	Дж. Бардин, Л. Купер, Дж. Шриффер, 1959
11. Нормальный металл с примесью переходного (d-) металла	Формирование локализованного магн. момента	Число электронов в d-состоянии с преимущественной ориентацией спина	П. Андерсон, 1961

чисто феноменологически и лишь затем получало обоснование и истолкование через микроскопич. параметры; как видно из столбца 4 таблицы, С. п. фактически применяется уже более ста лет, т. е. задолго до возникновения квантовой теории.

Исторически первое целенаправленное введение СП (тогда — внутреннее, или молекулярное, поля) считается принадлежащим Б. Л. Розанну (1892) и П. Вейсу (P. Weiss, 1907), применившим его в теории ферромагнетизма для объяснения существования спонтанной намагниченности. Однако ещё задолго до этого И. Д. Ван-дер-Ваальс (J. D. Van der Waals, 1873) фактически использовало понятие СП для учёта межмолекулярного взаимодействия при выводе ур-ния состояния классич. неидеальной газа.

В дальнейшем (30-е гг. 20 в.) С. п. плодотворно применялось рядом авторов к широкому классу объектов (антиферромагниты, ферриты, бинарные сплавы и т. п.), а позднее (40—50-е гг.) — к сегнетоэлектрикам, сверхпроводникам и др. С. п. успешно используется также в теории *неупорядоченных систем* (аморфные твёрдые тела, сплавные стёкла и т. п.). Практически все эти системы могут быть описаны с помощью эффективного *сплошного гамильтониана*. При этом оператор упорядочения является одна из компонент S^z оператора спина (квазиспина) S . В магнитоупорядоченных веществах таким оператором будет продольная (*Изинга модель*) или поперечная (XU -модель; см. *Двуэнергетные решёточные модели*) компонента оператора спина. В сверхпроводниках оператором упорядочения является поперечная компонента оператора квазиспина (совпадающая с оператором рождения куперовской пары), в ферромагн. металлах — продольная компонента оператора квазиспина (разность операторов числа электронов с противоположными спинами). Процедура введения СП состоит в замене одного из операторов S^z его ср. значением ($\langle S^z \rangle$), что позволяет линеаризовать гамильтониан и получить точное решение в рамках данной модели.

С. п. фактически эквивалентно применению вариационной принципа Н. Н. Боголюбова для свободной энергии (напр., применительно к магн. диэлектрикам), а также методу Л. Д. Ландау (*Ландау теория*) разложения свободной энергии по степеням параметра порядка вблизи критич. точки и таусовому приближению в методе континуального интегрирования для статистич. сумм. Ввиду своей физ. наглядности и матем. простоты С. п. является, как правило, необходимым первоначальным этапом решения задачи магн. тел практически для любой системы, особенно при наличии в ней дополнит. усложнений — сложной структуры кристаллич. или магн. элементарной ячейки, нарушения регулярной структуры кристалла, т. е. наличия примесей, вакансий и др. дефектов (см., напр., *Магнитный фазовый переход*). Однако в рамках С. п. п. невозможно описать динамич. свойства систем, прежде всего обстрел элементарных возбуждений, резонансные свойства и т. п.

Применение С. п. п. имеет опред. ограничения. Прежде всего оно теряет пригодность в тех случаях, когда флуктуация параметра порядка играют существенную роль, напр. в непосредств. окрестности точек фазовых переходов, где С. п. п. даёт завышенные значения самых этих точек, а также не согласующиеся с экспериментом значения *критических показателей*. С. п. п. не чувствуете тонких различий между нек-рыми системами (напр., ферромагнетиками Инанга и Гейзенберга) и даёт значения критич. показателей, не зависящие ни от размеров решётки d , ни от размерности параметра порядка l . К системам с такой размерностью ($d = 1, 2$), для к-рых имеются точные решения модельных задач или общие теоремы квантовой статистич. механики указывают на отсутствие фазовых переходов, С. п. п. вообще неприменимо.

Одним из обобщений С. п. п. (используемых, в частности, для магн. и сегнетоэлектрич. систем) является разложение свободной энергии и корреляц. ф-ций по обратным степеням радиуса обменного взаимодействия. Широко применяется также метод *ренормализационной группы* и *ε-разложения*, приводящих к появлению «траекторий» на плоскости (l, d) для критич. показателей, значения к-рых близки к экспериментально наблюдаемым.

Другим важнейшим обобщением С. п. п. является т. н. приближение случаевных фаз (ПСФ), к-рое представляет собой развитие идеи усреднения соответствующих операторов упорядочения. При этом усреднение операторов осуществляется не в гамильтониане, а при записи квантового уравнения движения. Наиб. завершение эта идея получила в методе ф-ций Грина. В квантовой теории магнетизма ПСФ носит название приближения Тябликова, в теории сверхпроводимости — *Бардина — Купера — Шриффера модели*, в теории неупорядоченных систем — приближения когерентного потенциала. ПСФ соответствует учёту влияния на каждое одночастичное состояние не только ср. статич. поля, как в С. п. п., но и норменных (осциллирующих) добавок к нему, возникающих благодаря частичному учёту корреляции между движениями различных (квази) частиц.

С. п. п. соответствует учёту только дальнего порядка, однако существует ряд способов его улучшения с целью учёта также эффектов корреляции, проявляющихся в наличии ближнего порядка. Среди них наиб. известны т. н. кластерные приближения. При этом оператор упорядочения задаётся не для узла решётки, а для кластера, включающего, напр., первую координац. сферу.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., *Статистическая физика*, ч. 1, 3 изд., М., 1976, гл. 8, 7, 13, 14; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., *Статистическая физика*, ч. 2, М., 1978; Таусел Д., *Квантовая механика систем многих частиц*, пер. с англ., 2 изд., М., 1975; Тябликов С. В., *Методы квантовой теории магнетизма*, 2 изд., М., 1975; Браут Р., *Фазовые переходы*, пер. с англ., М., 1967; Смита Л. К., *Эффективное поле в теории магнетизма*, пер. с англ., М., 1968; Стедди Г. Ф., *Фазовые переходы и критические явления*, пер. с англ., М., 1973; Исаев Ю. А., Касеев О. Г., Оглы Ф. А., Скрыabin Э. П., *Последние методы в теории ферромагнетизма*, М., 1974; Жук А. Я., Яковлев Д., *Статистическая теория твердого тела*, пер. с англ., М., 1975; Ма Ш., *Современная теория критических явлений*, пер. с англ., М., 1960; Займа В. Д., *Модели беспорядка*, пер. с англ., М., 1982.

А. В. Вейс, Ю. Г. Рудой.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ — то же, что *математическое ожидание*.

СРЕДНИЕ ВОЛНЫ — электромагнитные волны ср. частоты (0,3—3 МГц), длины к-рых лежат в интервале 100—1000 м. Условия распространения волн этого диапазона и характер изменения этих условий ото дня к ночи примерно одинаковы для волн всего диапазона. В дневные часы С. в. распространяются, как правило, в виде *земной волны*, поскольку уровня ионизации ионосферного слоя D недостаточно для отражения от него С. в., а поглощение в слое D столь велико, что для этих волн они практически непрозрачны (см. *Ионосфера*). В ночные часы слой D исчезает, С. в. достигает слоя E и отражаются от него по законам геом. оптики. Условия распространения земной волны практически не зависят от времени суток и определяются состоянием подстилающей поверхности (см. *Распространение радиоволн*). Макс. дальность распространения земной волны при существующих мощностях излучателей не превышает над сушей 500 км. В ночные часы результирующее поле волны в точке приёма вследствие флуктуат. изменений отражающих свойств ионосферы подвержено случайным колебаниям и характеризуется *замрачками* сигналов. Наб. сильно замрачения С. в. проявляются на расстояниях, где результирующее поле является суперпозицией волн — земной и отражённой от слоя E. Характеристика С. в., отражённых от слоя E полностью, определяется свойствами слоя и слабо зависит от 11-летнего цикла солнечной активности и ионосфер-

ных возмущений. Влияние сезонных изменений отражающих свойств волноферы в диапазоне С. в. сводится в осн. к изменению уровня поглощения С. в. В частности, поглощение С. в. увеличивается в летнее время по сравнению с зимним. В диапазоне С. в. проявляются нелинейные свойства волноферы, заключающиеся в том, что сигнал менее мощной станции оказывается промодулированным сигналам более мощной станции, когда траектории радиоволн в волнофере проходят через одну и ту же область (см. *Люксембург — Горьковский эффект*). С. в. применяется для радиосвязи на расстояниях до 1000—1500 км, в радиовещании, радионавигации, системах и приводных радиомаяках, в радиопеленгации.

Лит.: Альперт Я. Л., Распространение электромагнитных волн и волнофера, 2 изд., М., 1972; Долоуханов М. П., Распространение радиоволн, М., 1972; Чернышова В. Е., Чернышова О. В., Распространение радиоволн, М., 1984; Чернышова О. В., Распространение радиоволн, М., 1984; А. В. Рахлин.

СРОДСТВО К ЭЛЕКТРОНУ — свойство атомов или молекул образовывать прочную связь с электроном, т. е. отрицательный ион. Характеристикой такой связи является энергия сродства атомов или молекул к электрону — энергия связи электрона в соответствующем отриц. ионе, к-рая обычно обозначается EA (electron affinity). Эта энергия равна разности энергии нейтрального атома (молекулы) в основном состоянии и энергии осн. состояния образовавшегося отрицат.

Продолжение

№	Отрицательный ион	Структура верхней части электронной оболочки	Электронное состояние	EA, эВ	Класс точности
47	Ag ⁻	4d ¹⁰ 5s ²	¹ S _g	1,362	1
48	Ce ⁻	5p ²	нет	нет	0
49	In ⁻	5p ²	² P _g	0,3	4
50	Sn ⁻	5p ²	² S _g / _{1/2}	1,2	4
		5p ²	² D _g / _{3/2}	0,4	4
		5p ²	² F _g / _{7/2}	0,37	3
51	Sb ⁻	5p ²	² P _g	1,9708	0
52	Te ⁻	5p ²	² S _g	3,0591	0
53	I ⁻	5p ²	¹ S _g	нет	0
54	Xe ⁻	5d ¹⁰ 6s ²	¹ S _g	0,47163	0
55	Ba ⁻	6s ²	нет	нет	0
56	Ba ⁻	5d	² F _g	0,5	4
57	La ⁻	5d ¹⁰ 6s ²	нет	нет	0
72	Hf ⁻	5d ⁴ 6s ²	нет	нет	3
73	Ta ⁻	5d ⁴ 6s ²	² D _g	0,815	1
74	W ⁻	5d ⁴ 6s ²	нет	нет	0
75	Re ⁻	5d ⁴ 6s ²	² D _g	0,15	4
76	Os ⁻	5d ⁴ 6s ²	² F _g / _{7/2}	1,25	4
77	Ir ⁻	5d ⁴ 6s ²	² F _g / _{7/2}	1,585	1
78	Pt ⁻	5d ⁴ 6s ²	² D _g	2,128	0
79	Au ⁻	5d ¹⁰ 6s ²	¹ S _g	2,30863	0
80	Hg ⁻	6p ²	нет	нет	4
81	Tl ⁻	6p ²	² S _g	0,364	2
82	Pb ⁻	6p ²	² P _g	0,95	2
83	Bi ⁻	6p ²	² F _g / _{7/2}	1,9	4
84	Po ⁻	6p ²	¹ S _g	2,8	3
85	At ⁻	6p ²	нет	нет	0
86	Rn ⁻	7s ²	нет	нет	0
87	Fr ⁻	7s ²	¹ S _g	0,5	4

№	Отрицательный ион	Структура верхней части электронной оболочки	Электронное состояние	EA, эВ	Класс точности
1	H ⁻	1s ²	¹ S _g	0,75421	0
2	He ⁻	1s2s ²	0,07	3	3
3	Li ⁻	2s ²	¹ S _g	0,618	1
4	Be ⁻	2s ² 2p	нет	нет	0
5	B ⁻	2p ²	³ P _g	0,277	3
6	C ⁻	2p ²	³ S _g	1,269	1
		2p ²	¹ D	0,033	3
7	N ⁻	2p ²	нет	нет	0
8	O ⁻	2p ²	³ P _g / ₂	1,48112	0
9	F ⁻	2p ²	³ S _g	3,399	1
10	Ne ⁻	3s	нет	нет	0
11	Na ⁻	3s	¹ S _g	0,54793	0
12	Mg ⁻	3p	нет	нет	0
13	Al ⁻	3p ²	³ P _g	0,441	2
		3p ²	¹ D _g	0,41	3
14	Si ⁻	3p ²	³ S _g / _{1/2}	1,385	1
		3p ²	¹ P	0,523	1
		3p ²	¹ D	0,029	4
15	P ⁻	3p ²	³ P _g	0,7485	1
16	S ⁻	3p ²	³ P _g / ₂	2,07712	0
17	Cl ⁻	3p ²	³ S _g	3,817	0
18	K ⁻	4s	нет	нет	0
19	K ⁻	4s	¹ S _g	0,30147	0
20	Ca ⁻	4s ² 4p	¹ P	0,018	4
21	Sc ⁻	3d4s ² 4p	¹ D	0,09	4
		3d4s ² 4p	¹ F	0,14	3
22	Ti ⁻	3d4s ² 4p	³ F _g	0,08	4
23	V ⁻	3d ⁴ 4s	³ D _g	0,52	3
24	Cr ⁻	3d ⁴ 4s	³ S _g / _{1/2}	0,666	2
25	Mn ⁻	3d ⁴ 4s	нет	нет	0
26	Fe ⁻	3d ⁴ 4s	³ F _g / ₄	0,16	4
27	Co ⁻	3d ⁴ 4s	нет	нет	0
28	Ni ⁻	3d ⁴ 4s	³ D _g / _{3/2}	1,16	1
29	Cu ⁻	3d ⁴ 4s	¹ S _g	1,23	1
30	Zn ⁻	4p	нет	нет	0
31	Ga ⁻	4p ²	³ P _g	0,3	4
32	Ge ⁻	4p ²	³ S _g / _{1/2}	1,2	4
		4p ²	¹ D	0,4	4
		4p ²	¹ F	0,16	4
33	As ⁻	4p ²	³ P _g / ₂	2,02069	0
34	Se ⁻	4p ²	³ P _g / ₂	3,365	0
35	Br ⁻	4p ²	нет	нет	0
36	Kr ⁻	5s	нет	нет	0
37	Rb ⁻	5s	¹ S _g	0,48592	0
38	Sr ⁻	4d5s ² 5p	нет	нет	0
39	Y ⁻	4d5s ² 5p	¹ D	0,31	3
		4d5s ² 5p	¹ D	0,16	4
40	Zr ⁻	4d ⁴ 5s	³ P _g / ₂	0,43	4
41	Nb ⁻	4d ⁴ 5s	³ D _g	0,89	2
42	Mo ⁻	4d ⁴ 5s	³ S _g / _{1/2}	0,75	2
43	Tc ⁻	4d ⁴ 5s	³ D _g	0,55	4
44	Ru ⁻	4d ⁴ 5s	³ F _g / ₄	1,0	4
45	Rh ⁻	4d ⁴ 5s	³ F _g / ₄	1,14	3
46	Pd ⁻	4d ⁴ 5s	³ S _g / _{1/2}	0,56	2
		4d ⁴ 5s	³ D _g / _{3/2}	0,42	2

нона. У большинства атомов С. к з. связано с тем, что их внеш. электронные оболочки не заполнены (см. *Атом*). В табл. приводятся значения энергии С. к з. атомов в осн. состоянии. Осн. и наиб. точная часть этой информации получена при исследовании фотосрада отриц. ионов. В одном варианте этого метода отриц. ионы разрушаются под действием лазерного излучения данной длины волны, энергия связи электрона устанавливается по измерению энергии освободившихся электронов. В др. варианте данного метода для фотосражения отриц. ионов используется излучение перестраиваемого лазера, что позволяет определить положение порога фотосрада отриц. иона, а по нему и энергию связи электрона. Фотоселективный и лазерный методы определения энергии связи электрона в отрицат. ионе являются главными и при исследовании молекулярных отриц. ионов. В табл. указан класс точности определения энергии С. к з.: 0 означает точность лучше 0,1%, 1 — лучше 1%; 2 — лучше 3%; 3 — выше 10%; 4 — хуже 10%. Отриц. ион Ne построен на метастабильном атоме Ne. Этот в табл. означен, что стабильный отрицат. ион данного элемента не образуется.

Величины EA молекул и радикалов колеблются в широком пределе. В ряде случаев они составляют от единиц эВ, во для NO, EA > 3 эВ, для OH EA ≈ 2 эВ, для CN EA > 3 эВ.

Лит.: Таблицы физических величин. Справочник, под ред. И. К. Кирикова, М., 1976; Рэддинг А. А., Смирнов Б. М., Параметры атомов и атомных ионов. Справочник, М., 1986.

СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕУСТОЙЧИВОЙ ПЛАЗМЫ, удерживаемой магнитным полем, — осуществление условий, при к-рых неустойчивости, опасные для удержания плазмы, не реализуются. Проблема С. в. п. возникла в исследованиях по управляемому термоядерному синтезу. Крупномасштабные МГД-неустойчивости могут полностью разрушить равновесную конфигурацию высокотемпературной плазмы, как это происходит, напр., при возникновении неустойчивости сырыя в токамаке. Вместе с условием равновесия они устанавливают верх. предел допустимого отношения ср. давления плазмы $\langle p \rangle$ к давлению внешнего удерживающего магн. поля: $\beta = 2\langle p \rangle / B^2$. Маломасштабные неустойчивости, не разрушающие равновесия, могут приводить к аномально большому потере частиц и энергии из плазмы, к появлению уско-

ренных электронов, к-рые могут повредить стенки вакуумной камеры, и т. д. Поэтому С. и. п. — одно из гл. условий создания *термоядерного реактора* с магн. удержанием.

Важнейший метод С. и. п. — выбор такой конфигурации удерживающего магн. поля, чтобы самой его геом. формой сдерживать развитие неустойчивостей, стабилизировать их на нач. стадии развития; набр. часто для этого используются шир (от англ. shear — сдвиг) и магнитная яма.

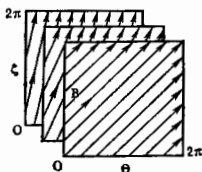
Стабилизация широм. Шир в тороидальных системах характеризует перекрещивание силовых линий, изменение ср. шага $h = L/\mu = Lq$ винтообразных магн. силовых линий при переходе в радиальном направлении от одной магн. поверхности к другой и определяется ф-лой

$$s = aq'(a)/q = -a\mu'(a)/\mu. \quad (1)$$

Здесь L — длина тора, равная для круговых систем $2\pi R$, R — радиус тора, a — ср. радиус сечения нек-рой магн. поверхности в торе, μ — вращательное преобразование в а. н. е., определяющее число оборотов магн. силовых линий по малому обходу тора, приходящемуся на один обход вдоль тора, $q = 1/\mu$ — безразмерный параметр, характеризующий шаг силовой линии. В потоковых координатах a, Θ (см. *Тороидальные системы*) магн. силовые линии являются прямыми и имеют разный наклон на поверхностях с широм $s \neq 0$ (рис. 1). Возникающая при развитии неустойчи-

Рис. 1. Магнитное поле с широм в тороидальных системах.

Изображены три тороидальные магнитные поверхности $a = \text{const}$. В координатах Θ, ζ все они имеют форму квадрата со сторонами $2\pi \times 2\pi$. Изменение наклона магнитных силовых линий означает наличие шира, не равного нулю.



вости конвекция плазмы происходит вследствие высокой электропроводности плазмы пельми магн. трубками. Но они оказываются сцепленными (перекрещиваются) при $s \neq 0$, что и сдерживает развитие неустойчивости. В результате, напр., необходимое условие устойчивости плазмы в торе круглого сечения при $a^2/R^2 \ll q \ll 1$ (критерий Сайдема) имеет вид:

$$\frac{a^4}{4} + \frac{2\mu\mu'(a)}{B^2} \geq 0. \quad (2)$$

Шир не препятствует, однако, развитию медленных диссипативных неустойчивостей, для к-рых не существует топологии запрета, связанного с зацеплением магн. силовых линий. Более универсальным средством С. и. п. является магн. яма.

Стабилизация магнитной ямой. Неустойчивости, вызываемые градиентом давления, связаны с выпуклостью магн. силовых линий. В бестоковых системах (открытых лопухах, стеллараторах) это соответствует наличию магн. бугра (максимума B^2 на оси системы, рис. 2, а). Для стабилизации этих неустойчивостей в открытых магн. лопухах магн. поле можно создать нарастающим не к центру, а от центра во всех направлениях (абс. минимум B в центре) путём пропускания в продольных проводниках, окружающих лопуху (т. н. стержни Иоффе), токов чередующегося направления. В случае четырёх стержней (к-рые могут быть объединены с катушками продольного магн. поля в единственную бейсбольную обмотку; рис. 2, в) поперечное магн. поле создаст систему с вогнутыми магн. силовыми линиями, т. е. с магн. ямой.

Стабилизация плазмы возможна также с средним минимумом B , или средней магн. ямой,

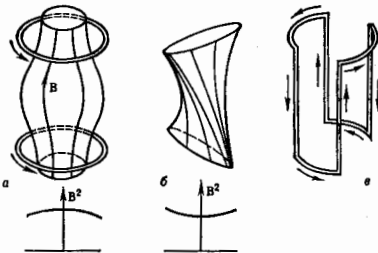


Рис. 2. Стабилизация магнитной ямой в открытых лопухах: а — выпуклые магнитные силовые линии и магнитный бугор в осесимметричной лопухе с магнитными пробками; б — открытый магнитный лопух с вогнутыми магнитными силовыми линиями и магнитной ямой; в — схема обмотки для создания лопуха с магнитной ямой, в которой стержни Иоффе объединены в единую обмотку бейсбольного типа.

при знакопеременной кривизне магн. силовых линий, т. к. из-за высокой электропроводности плазмы стабилизирующее влияние вогнутых участков силовых линий распространяется на всю магн. трубку. Это позволяет сделать плазму устойчивой в осесимметричной открытой лопухе, а также и в тороидальных системах, используя вогнутость магн. силовых линий с большим шагом $h \sim L$ на внутр. стороне тора. Для создания ср. магн. ямы нужно сместить магн. ось с помощью поперечного магн. поля к внеш. обводу тора в область ослабленной напряжённости тороидального магн. поля (рис. 3). В томаке это происходит автоматически, в результате во втором слагаемом в критерии (2) появляется множитель $(1 - q^2)$. В нек-рых условиях для углубления магн. ямы в тороидальных системах достаточно смещения магн. оси из-за наличия градиента давления плазмы (эффект самостабилизации плазмы). При этом область устойчивости с новым давлением может быть отделена от области устойчивости с низким давлением плазмы (2-я и 1-я зоны устойчивости).

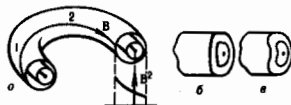


Рис. 3. Образование средней магнитной ямы в тороидальных системах с $q > 1$: на наружном обходе тора (а) магнитная силовая линия выпукла (участок 2), на внутреннем — вогнута (участок 1). Выпад вогнутого участка тем больше, чем больше магнитная ось смещена в внешнюю сторону тора. Этому способствует создание D-образной (б) или боообразной (в) усреднённой форм поперечного сечения магнитной поверхности.

Кроме использования геом. свойств магн. поля для С. и. п. широко применяются активные методы воздействия на плазму. К ним относятся: 1) поддержание благоприятных для устойчивости плазмы профилей тока, темп-ры, давления с помощью локального подогрева плазмы, напр. при резонансном поглощении ВЧ-волн, путём локальной генерации тока СВЧ-методами, поддува газа на край плазмы, инжекции крилоносного вещества, на к-рого создается плазма, в центр плазменного шнура и т. п.; 2) подавление неустойчивостей системой автоматич. управления (метод обратных связей); 3) управление ф-цией распределения заряж. частиц по скоростям, напр. варьированием ВЧ-методов нагрева, при к-рых энергия вкладывается протом. в продольную или поперечную степень свободы частиц,

либо непрерывной инжекцией пучка ускоренных атомов, создающих после ионизации их в плазме популяции частиц с определ. распределением по скоростям. Такое воздействие на ф-цию распределения позволяет осуществлять контроль за нек-рыми кинетич. неустойчивостями.

При нек-рых условиях С. н. п. может осуществляться самопринудительно как переход в энергетически более выгодное состояние, когда вследствие развития неустойчивости происходит подстройка процессов переноса частиц и энергии таким образом, чтобы реализовались устойчивые распределения тока, темп-ры и т. д. Такая самоорганизация плазмы наиб. отчетливо проявляется в токовых системах — токамаках и пинчах с обращенным магн. полем.

Лит.: Аринкович Л. А., Сагдеев Р. З., Физика плазмы для физиков, М., 1978; Основы физики плазмы, под ред. А. А. Гезлева, Р. Судана, т. 1, М., 1983; К а л о м и ц в Б. В., Коллективные явления в плазме, М., 1988. В. Д. Шобранов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ — поддержание заданного значения напряжения (или тока) при изменении сопротивления нагрузки, напряжения питания и т. п. Для С. т. и в. обычно применяются электронные устройства. Напряжение (ток) нагрузки слабо зависит от её импеданса, если внутр. сопротивление источника напряжения (тока), подключаемого к нагрузке, намного меньше (больше) сопротивления этой нагрузки (рис. 1). Для этой цели в простейших

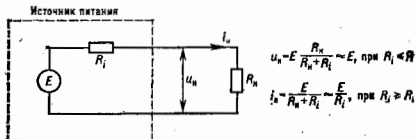


Рис. 1. R_n — сопротивление нагрузки, R_1 , E — внутреннее сопротивление и напряжение источника питания; U_u , I_u — напряжение и ток нагрузки.

стабилизаторах напряжения (СН) служит эмиттерный повторитель напряжения, а в стабилизаторах тока (СТ) нагрузка включается в цепь коллектора *транзистора биполярного* или в цепь стока *полевых транзистора*. В более сложных стабилизаторах используются отрицат. обратная связь. Напряжение на нагрузке (или напряжение, пропорциональное току в нагрузке) сравнивается с заводом стабильным, т. н. опорным, напряжением, и усиленный сигнал рассогласования подается на элемент, непрерывно регулирующий напряжение (ток) нагрузки таким образом, чтобы уменьшить сигнал рассогласования до нуля (рис. 2). Точ-

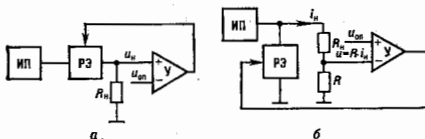


Рис. 2. Блок-схемы стабилизаторов напряжения и тока: а — последовательный тип; б — параллельный; РЭ — регулирующий элемент, У — сравнивающее устройство и усилитель сигнала рассогласования, ИП — источник питания.

ность, с к-рой поддерживается стабильность напряжения (тока), определяется глубиной обратной связи, стабильностью опорного напряжения и точностью сравнивающего устройства. Регулирующий элемент (обычно биполярный транзистор) включается параллельно (СН и СТ параллельного типа) или последовательно (СН и СТ последоват. типа) с нагрузкой. В ка-

честве сравнивающего устройства и усилителя сигнала рассогласования обычно служат *операционные усилители*. В устройствах стабилизации пост. напряжений и токов опорное напряжение обычно создается полупроводниковым или газоразрядным стабилизатором — прибором, напряжение на к-ром слабо зависит от протекающего по нему тока. Параллельное соединение стабилизатора и нагрузки широко используется в простейших маломощных стабилизаторах напряжения (т. н. параметрической СН).

СН и СТ с непрерывным управлением регулирующим элементом обладают сравнительно низким кд из-за пост. рассеяния мощности на регулирующем элементе. Для увеличения кд применяются импульсные, или ключевые, СН и СТ (рис. 3). Регулирующий эле-

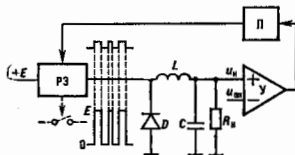


Рис. 3. Блок-схема импульсного стабилизатора напряжения. П — преобразователь сигнала рассогласования в импульсное напряжение управления РЭ.

мент, включенный последовательно с нагрузкой, работает как электронный ключ и быстро переключается между двумя состояниями: разомкнутым (сопротивление ключа очень большое, ток ключа равен нулю) и замкнутым (сопротивление ключа близко к нулю, напряжение на ключе — малое). В таком режиме работы регулирующий элемент рассеивает энергию преим. в моменты переключения. Выходное напряжение ключа имеет форму прямоуго. импульсов с амплитудой, равной напряжению источника питания E . Это напряжение сглаживается с помощью фильтра низких частот, состоящего из последовательно включенной катушки индуктивности L и конденсатора емкости C , подключаемого параллельно нагрузке. Пост. напряжение, к-рое получается на выходе фильтра, зависит от соотношения между временем замкнутого и временем разомкнутого состояний. Отношение времён изменяется в соответствии с сигналом рассогласования между напряжением (током) нагрузки и опорным напряжением. Тем самым стабилизируется напряжение (ток) нагрузки. С помощью диода D во время разомкнутого состояния ключа в нагрузку передается энергия, запасенная в катушку индуктивности. Кд импульсных СН и СТ достигает 80% и более. При стабилизации высоких напряжений СН обычно совмещают с преобразователем напряжения.

Лит.: Хоровиц П., Хилл У., Искусство схемотехники, пер. с англ., 3 изд., т. 1, М., 1986; Т и т. е. У., Шейн и К., Полупроводниковая схемотехника, пер. с нем., М., 1982; Источники электричества радиоэлектронной аппаратуры. Справочник, под ред. Г. С. Найфельта, М., 1985. А. В. Степанов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ — совокупность методов увеличения *стабильности частоты*. Различают: а) *затухание частоты* путём связи генератора колебаний с доплотит. колебат. системой, характеризуемой высокой *добротностью*; б) *затухание частоты* путём связи данного генератора колебаний с генератором, обладающим более стабильной частотой; в) параметрическую С. ч. — стабилизацию параметром приборов, генерирующих периодич. колебания.

Типичным примером С. ч. путём *з а т у х а н и я* является связь генератора радиочастотных колебаний с кварцевым резонатором. Эффект С. ч. возникает при этом за счёт того, что частота генерируемых колебаний удерживается внутри резонансной кривой квар-

целого резонатора, на неск. порядков более узкой, чем ширина резонансной кривой резонансного контура генератора (см. *Генератор электромагнитных колебаний*). Кроме того, зависимость резонансной частоты кварцевого резонатора от температуры на неск. порядков меньше, чем у обычного резонансного контура. В результате частота колебаний слабо зависит от изменений параметров колебат. контура и удерживается вблизи верхним резонансной кривой кварцевого резонатора.

С. ч. путем за х а в т а в н и я используют для С. ч. мощного генератора, воздействуя на него сигналом более стабильного малоомного генератора. При этом необходимо обеспечить малость обратного воздействия мощного генератора на малоомный. Этот метод применим, напр., для С. ч. *магистронов*, воздействуя на него гармоникой кварцевого резонатора.

Наиб. гибким и эфф. методом является параметрич. С. ч. При этом выбирают спектральные (резонансные) системы, вещество и конструкция к-рых слабо реагируют на изменение веш. условий. Наиб. простая система, в к-рой используются параметрич. С. ч., — маятниковые часы. Стабильность их хода зависит от стабильности параметров маятника (его приведенной длины), от стабильности влияния на частоту колебаний маятника, поддерживающего его колебания. В результате стабилизации этих параметров погрешность хода астрономич. маятниковых часов составляет 10^{-8} , что на 2 порядка лучше, чем у обычных часов. Погрешность частоты кварцевого генератора может быть доведена до 10^{-11} .

К параметрич. методам С. ч. относится переход от макроскопич. резонансных систем к микросистемам, квантовая структура к-рых придает им резонансные свойства, проявляющиеся в их узких спектральных линиях. Первым из таких устройств был *молекулярный генератор*, в к-ром резонансный процесс сводится к инверсионным переходам между энергетич. уровнями молекул аммиака. Макроскопич. объёмный резонатор служит в этом приборе только для обеспечения *обратной связи*. Существенно более высокой стабильностью частоты обладает *водородный генератор*, обеспечивающий воспроизводимость частоты с погрешностью 10^{-13} при относит. стабильности $2 \cdot 10^{-14}$.

Совр. эталоны частоты опираются на спектральные линии атомов Св, наблюдаемые в атомных пучках (см. *Квантовые стандарты частоты*). По получаемой т. о. атомальной частоте производят автоматич. подстройку частоты вспомогат. кварцевого генератора, а по его сигналу при помощи синтезатора получают набор эталонных частот, служащих для калибровки вторичных стандартов (мер) частоты.

Дальнейшее уменьшение погрешности эталонов частоты может быть достигнуто путем сужения спектральных линий атомов, служащих реперами частоты, напр. охлаждением атомных пучков или наблюдением спектральных линий атомов, удерживаемых в эл.-магн. ловушках.

СТАБИЛИТРОН газоразрядный — цинковый прибор, предназначенный для поддержания на неизменном уровне (стабилизации) напряжения источников питания или узлов радиоэлектронной аппаратуры. С. представляет собой двухэлектродные устройства, к-рые в зависимости от вида элктрич. разряда, используемого в них, подразделяются на С. тлеющего разряда и С. коронного разряда.

Стабилизаторы тлеющего разряда имеют почти горизонтальную вольт-амперную характеристику (рис. 1). Стабилизирющее действие основано на незначительном изменении падения потенциала в тлеющем разряде и довольно большом диапазоне токов $I_{ст\ мин} - I_{ст\ макс}$ соответствующих нормально тлеющему разряду ($1 - 10$ мА). Такую характеристику имеет С. при условии небольших межэлектродных расстояний, когда полное падение потенциала между анодом и катодом равно катодному падению потенциала, величина к-рого

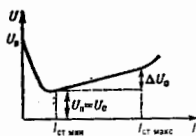


Рис. 1. Вольт-амперная характеристика стабилизатора тлеющего разряда.

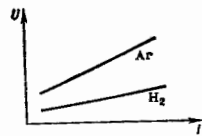


Рис. 2. Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда короны для H_2 и Ar.

остается практически неизменной. Конструктивно С. тлеющего разряда выполняются с цилиндрич. концентр. электродом. Функции анода выполняет стержень или проволока; окружающий его цилиндр является катодом. Баллон вакуумируется и наполняется смесью инертных газов, вариации к-рых вместе с разл. технол. способами обработки катодов позволяют изменять диапазон стабилизации напряжения от 50 до 160 В; срок использования С. более 10 000 ч. Осн. параметры С. тлеющего разряда: U_0 — напряжение возникновения разряда; $U_{ст}$ — напряжение поддержания разряда, соответствующее напряжению стабилизации $U_{ст}$; ΔU_0 — изменение напряжения стабилизации при изменении тока в рабочем диапазоне; $I_{ст\ макс}$, $I_{ст\ мин}$ — макс. и мин. значения токов, между к-рыми осуществляется стабилизация напряжения; $R_{д}$ — дифференц. сопротивление С., характеризующее стабилизирующее действие прибора; ТКН — температурный коэф. напряжения стабилизации, характеризующий изменение напряжения С. при изменении температуры окружающей среды.

Стабилизаторы коронного разряда используются для стабилизации более высоких напряжений (до ≥ 30 кВ). В основе работы приборов этого типа также лежит почти независимость $U_{ст}$ от I ; вольт-амперная характеристика коронного разряда при опред. выборе геом. параметров и газового наполнения прибора близка к горизонтальной (рис. 2). В С. коронного разряда используется положит. корона (коронирующий электрод меньшего радиуса — анод) в водороде с давлением, превышающим атмосферное. Конструктивно эти приборы выполняются в металлокерамич. баллоне с бесполовым оформлением и выводами в разные стороны. Параметры С. коронного разряда такие же, как у С. тлеющего разряда, особенною лишь является отсутствие у С. коронного разряда различия между напряжением возникновения разряда и напряжением стабилизации при $U_{ст} > 4$ кВ.

Лит.: К о в а л ь о в И. Л., Ионные приборы, М., 1972; см. также лит. при ст. Ионные приборы. А. С. Шчелоко. **СТАБИЛИТРОН** (от лат. stabilis — устойчивый, постоянный) полупроводниковый — прибор, предназначенный для стабилизации напряжения в элктрич. цепях (см. *Стабилизация тока и напряжения*). Представляет собой диод, работающий при обратном напряжении; вольт-амперная характеристика (ВАХ) С. (рис.) имеет участок с очень слабой зависимостью напряжения от тока (дифференц. сопротивление мало). Физ. механизмом, обуславливающим

Обратная вольт-амперная характеристика стабилизатора: С — точка стабилизации; $R_{д}$ — нагрузочная приман.

возникновение такого участка, является лавинный либо туннельный пробой $p-n$ -перехода. Конструктивно С. представляет собой $p^{+}n^{+}p$ -диод, в к-ром приняты меры по повышению однородности пробы: специальной конструкцией краевого контура $p-n$ -перехода уст-

равна возможность пробы по поверхности, а полупроводниковый материал имеет повмн. однородность уд. сопротивления ρ . В области малых напряжений «студенка» тока определяется в осн. генерац. процессами в базовой области на расстояния диффузионной длины от p^+ — n -перехода («ток насыщения»). При больших напряжениях определяющей становится генерация в области *пространственного заряда* (ОПЗ) p — n -перехода, к-рая расширяется с ростом напряжения. В точке *A* напряженность поля ОПЗ в области максимума достигает величины, при к-рой рост обратного тока уже определяется ударной либо туннельной ионизацией, а в точке *B* при $U = U_{пр}$ происходит пробой и наклон характеристики резко меняется. Этот наклон зависит от мн. факторов: от вида пробы, его однородности, величины уд. сопротивления материала и т. д. Для кремниевых p — n -переходов, напр., до напряжения $U_{пр} \lesssim 5$ В определяющим является туннельный, а при $U_{пр} \gtrsim 7$ В — лавинный пробой, дающий значительно более крутой наклон ВАХ. Однако лавинный пробой развзается, как правило, неоднородно по площади, а в локальных участках — в областях т. н. микроплазмы, где имеются значит. искажения поля в ОПЗ, происходящие из-за разл. рода дефектов, а также неоднородностей поля, связанных с неоднородностью легирования.

ВАХ С. после участка *AB* становится практически линейной, поскольку при большом напряжении практически все области микроплазмы находятся в стабильном проводящем состоянии и их линейные характеристики суммируются.

Осн. параметрами С. являются: динамич. сопротивление $R_d = dU/dI$ при $I = I_{ст}$; статич. сопротивление $R = U_{ст}/I_{ст}$; коэф. качества $Q = R_d/R$; температурный коэф. напряжения $TKN = dU_{ст}/dT$.

Напряжение стабилизации $U_{ст}$ связано с напряжением пробы, но не равно ему, т. к. ВАХ имеет определ. крутизну. Для однозначного определения $U_{ст}$ задают некоей определ. величиной тока $I = I_{ст}$ так, чтобы эта точка была на участке *AB*. Отклонение тока от этой величины будет приводить к изменению напряжения на диоде; динамич. сопротивление $R_d = dU/dI$ характеризует степень стабилизации. Статич. сопротивление R характеризует потери в диоде в заданной рабочей точке. Коэф. качества

$$Q = (I_{ст} U_{ст}) / dU/dI$$

представляет собой отношение оснот. изменения напряжения на С. к относит. изменению тока. Качество С. тем выше, чем меньше Q . Очень важный параметр — температурный коэф. напряжения. В случае лавинного пробы $U_{пр}$ с темп-рой возрастает; это происходит из-за уменьшения ср. длины свободного пробега носителей вследствие возрастания рассеяния на фоновых рещётки. Поскольку с уменьшением длины свободного пробега носителей заряд энергия, достаточная для ионизации рещетки, может быть набрана в более сильном поле, напряжение пробы растёт с темп-рой, причём скорость роста довольно велика ($TKN \sim 0,1\%/K$). При туннельном пробое $U_{пр}$, наоборот, уменьшается с ростом темп-ры из-за уменьшения ширины запрещённой зоны; характерная величина $TKN \sim 0,03 \div 0,07\%/K$. Минимальный TKN имеют кремниевые С. с $U_{пр} = 5 \div 7$ В, когда туннельный и лавинный пробы развиваются одновременно.

У выпускаемых промышленностью С. напряжение стабилизации лежит в диапазоне 2,2—200 В, ток стабилизации — от долей миллиампера до единиц ампер. Осн. полупроводниковым материалом для С. являются кремний, осн. технол. методы изготовления p^+ — n — n^+ -структуры — термодиффузия примесей, силважение, *эптаксия*.

Лит.: Федотов Я. А., Основы физики полупроводниковых приборов, 2 явл., М., 1970; Грехов И. В., Серезинский И. Ю., Лавинный пробой p — n -перехода в полупроводниках, Л., 1980.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ — основная характеристика периодич. процессов, а также характеристика приборов и устройств, генерирующих периодич. колебания (см. *Автоколебания*). С. ч. характеризуется зависимостью частоты от времени. Измерение С. ч. сводится к сравнению частоты данного генератора с частотой более стабильного источника, напр. с образцовой мерой частоты или с эталоном частоты. Результат сравнения зависит от затраченного времени. Это значит, что С. ч. данного источника колебаний не является вполне определенной величиной. Различают кратковременную С. ч., отображающую влияние флукутаций, процессов, и долговременную С. ч., зависящую от изменений параметров генератора колебаний вследствие внеш. воздействий. Иногда говорят об абсолютной и относительной С. ч., имея в виду соответственно изменение значения частоты генератора при многократных включениях и выключениях и изменение значения частоты генератора при его непрерывной работе. Последняя может быть определена не только путём сравнения с эталоном, но и измерением автокорреляции частоты генерируемого колебания.

С. ч. называют естественной, если она ограничена флукутациями, возникающими внутри источника колебаний, напр. вследствие тепловых движений или флукутаций тока (см. *Дробовой шум*). С. ч., определяемую изменениями параметров генератора под влиянием внеш. воздействий, называют *технической*. Исследования С. ч. показывают, что естеств. С. ч. связана с шириной спектральной линии генератора, а технич. С. ч. — с медленными или скачкообразными изменениями его параметров. Напр., С. ч. *старородного генератора* ограничивается медленным старением защитной плёнки, уменьшающей влияние поверхности стенки на удерживающие её атомы водорода.

М. Е. Жабитский.

СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ — то же, что *квадратичное отклонение*.

СТАТИКА (от греч. *statiké* — учение о весе, равновесии) — раздел *механики*, посвященный изучению условий равновесия материальных тел под воздействием сил.

В зависимости от положенных в основу принципов С. разделяют на аналитическую и геометрическую. В основе аналитической С. лежит *возможных перемещений принцип*, дающий общие условия равновесия любой механич. системы. Геометрическая С. основывается на т. н. аксиомах С., выражающих свойства сил, действующих на материальную часть и абсолютно твёрдое тело, т. е. тело, расстояния между точками к-рого всегда остаются неизменными. Осн. аксиомы С.: 1) две силы, действующие на материальную часть, имеют равнодействующую, определяемую по правилу параллелограмма сил; 2) две силы, действующие на материальную часть (или абсолютно твёрдое тело), уравновешиваются только тогда, когда они одинаковы по величине и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны; 3) прибавление или вычитание уравновешенных сил не изменяет действия данной системы сил на твёрдое тело. При этом уравновешенными из. сил, под действием к-рых свободное твёрдое тело может находиться в покое по отношению к *инерциальной системе отсчёта*.

Методами геометрической С. изучается С. твёрдого тела. При этом рассматриваются решения следующих двух типов задач: 1) приведение систем сил, действующих на твёрдое тело, к простейшему виду; 2) определение условий равновесия сил, действующих на твёрдое тело. Геометрическую С. можно также строить непосредственно исходя из *Ньютона законов механики* и вытекающих из этих законов общих теорем *динамики*.

Необходимые и достаточные условия равновесия упруго деформируемых тел, а также жидкостей и газов рассматриваются соответственно в *упругости теор.*, *гидростатике* и *аэростатике*.

К осн. понятиям S , относятся понятия о моменте силы относительно центра и относительно осн и о паре сил. Сложение сил и их моментов относительно центра производится по правилу сложения векторов. Величина R , равная геом. сумме всех сил F_k , действующих на данное тело, наз. гл. вектором этой системы сил, а величина M_0 , равная геом. сумме моментов $m_0(F_k)$ этих сил относительно центра O , наз. гл. моментом системы сил относительно указанного центра:

$$R = \sum_k F_k, \quad M_0 = \sum_k m_0(F_k). \quad (1)$$

Решение задачи приведения сил даёт следующий осн. результат: любая система сил, действующих на абсолютно твёрдое тело, эквивалентна одной силе, равной гл. вектору R системы и приложенной в произвольно выбранном центре O , и одной паре сил с моментом, равным гл. моменту M_0 системы относительно этого центра. Отсюда следует, что любую систему действующих на твёрдое тело сил можно задать еб гл. вектором и гл. моментом, — результат, к-рым широко пользуются на практике при задании, напр., аэродинамич. сил, действующих на самолёт или ракету, усилий в сечениях балки и др.

Простейший вид, к к-рому приводится данная система сил, зависит от значений R и M_0 . Если $R = 0$, $M_0 \neq 0$, то данная система сил заменяется одной парой с моментом M_0 . Если $R \neq 0$, $M_0 = 0$ или $M_0 \neq 0$, но векторы R и M_0 взаимно перпендикулярны (что, напр., всегда имеет место для параллельных сил или сил, лежащих в одной плоскости), то система приводится к одной равнодействующей, равной R . Наконец, когда $R \neq 0$, $M_0 \neq 0$ и эти векторы не взаимно перпендикулярны, система сил заменяется совокупным действием силы и пары сил (или двумя скрепляющимися силами) и равнодействующей не имеет.

Для равновесия любой системы сил, действующих на твёрдое тело, необходимо и достаточно обращение величин R и M_0 в нуль. Вытекающие отсюда ур-ния, к-рым должны удовлетворять действующие на тело силы при равновесии, см. в ст. *Равновесие механической системы* [ур-ния (1)]. Равновесие системы тел изучают, составив ур-ния равновесия для каждого тела в отдельности и учитывая закон равенства действия и противодействия. Если общее число реакций связей окажется больше числа ур-ний, содержащих эти реакции, то соответствующая система тел является статически неопределимой; для изучения её равновесия надо учесть деформации тел.

График. методы решения задач S , основываются на построении многоугольника сил и вербального многоугольника.

Лит.: Жуковский Н. Е., Теоретическая механика, 2 изд., М., — Л., 1952; Дойчманьян Я. Г., Дурье А. И., Курс теоретической механики, т. 1, 8 изд., М., 1982; Тарг С. М., Краткий курс теоретической механики, 10 изд., М., 1986; см. также лит. при ст. *Механика*. С. М. Тарг.

СТАТИСТИКА ФОТООТСЧЕТОВ — вероятностное описание потока событий (отсчётов), происходящих в счётчике фотонов (фотодетекторе) под действием падающих на него световых квантов. Метод счёта фотонов используется при регистрации слабых световых потоков, когда фотодетектор успеваеt задержать предыдущий отсчёт к приходу последующего фотоотсчёта. Регистрация последовательности фотоотсчётов и их статистич. обработка предпринимаются для установления свойств света того или иного источника, а также свойств среды, воздействующей на проходящий через неё свет. В качестве счётчиков фотонов используют *фотоэлектронные умножители* и лавинные фотодиоды (чувствительные в видимом, УФ- и ближнем ИК-диапазонах спектра эл.-магн. излучения), фотоэлектронные умножители со сцинтилляторами (в УФ- и рентг. диапазонах); в более длинноволновом диапазоне могут использоваться атомные пучки. Выходные электроны,

импульсы в таких фотодетекторах, являющиеся откликом на фотон, имеют конечную длительность. Однако при анализе фотоотсчёты считают точечными событиями, т. е. происходящими мгновенно, ирравильный момент отсчёта, напр., к максимуму импульса. Такая идеализация позволяет рассматривать фотоотсчёты как поток точечных событий. Существенно вероятностный характер взаимодействия фотонов с атомами фотоувеличит. площадки фотодетектора приводит к тому, что момент отсчёта не детерминируется, и в результате поток фотоотсчётов имеет случайный характер.

Поток фотоотсчётов характеризуется следующими параметрами: числом отсчётов в заданном интервале времени; временным интервалом между соседними отсчётами; временем появления первого отсчёта после заданного момента времени; частотой совпадений отсчётов разных счётчиков, находящихся в одном потоке фотонов, и т. д. Многократные измерения этих характеристик с последующей статистич. обработкой позволяют установить такие свойства регистрируемого излучения, как распределения числа фотонов и интенсивности, корреляц. свойства и степень когерентности, временной ход интенсивности, а также не-р-ые другие.

Наиб. распространение получили измерения распределения числа отсчётов в заданном интервале времени от t до $t + T$: $P_m(t, T)$ — вероятность регистрации m отсчётов в интервале времени T . Связь распределения $P_m(t, T)$ с характеристиками света основывается на соотношениях *квантовой оптики*. Однако в классич. пределе, когда поток фотонов, выраженный их числом в объёме когерентности (см. *Когерентность света*), велик и излучение можно характеризовать классической (не операторной) величиной интенсивности $I(t, x, y)$ [Вт/см²] (где x, y — координаты фотоувеличит. площадки счётчика), связь $P_m(t, T)$ с характеристиками света устанавливается из простых соображений о независимости отсчётов друг от друга [4]. В этом случае распределение $P_m(t, T)$ определяется полной энергией излучения Q , улавливаемой на счётчик за время регистрации T , и квантовой эффективностью счётчика η :

$$P_m(t, T) = (m!)^{-1} (\eta Q / h\nu)^m \exp(-\eta Q / h\nu), \quad (1)$$

где

$$Q = \int_S \int_V^t \int_V^{t+T} I(t', x, y) dt' dx dy.$$

Энергия фотона $h\nu$, входящая в (1), не придаёт квантового характера этому соотношению, т. к. она появилась в (1) из определения квантовой эффективности счётчика: η есть вероятность отсчёта при падении на счётчик одного фотона, $0 < \eta \leq 1$. Если излучение освещает фотоувеличит. площадку S счётчика равномерно и с пост. интенсивностью I , то распределение числа фотоотсчётов не зависит от времени t и является пуассоновским:

$$P_m(T) = (m!)^{-1} (\eta I T S / h\nu)^m \exp(-\eta I T S / h\nu). \quad (2)$$

Величина $\eta I T S / h\nu$ определяет ср. число фотоотсчётов $\langle m \rangle = \eta I T S / h\nu$ и все высшие факториальные моменты распределения $P_m(T)$:

$$\begin{aligned} \langle m(m-1) \dots (m-k+1) \rangle &= \sum_{m \geq k} m(m-1) \dots (m-k+1) P_m(T) = \\ &= \langle m \rangle^k \equiv (\eta I T S / h\nu)^k. \end{aligned}$$

В частности, дисперсия пуассоновского распределения совпадает со ср. значением:

$$\langle \Delta m^2 \rangle \equiv \langle m - \langle m \rangle^2 \rangle = \langle m \rangle,$$

а относит. среднеквадратичное отклонение числа отсчётов обратно пропорционально квадратному корню из среднего:

$$\sqrt{\langle \Delta m^2 \rangle} / \langle m \rangle^2 = 1 / \sqrt{\langle m \rangle}.$$

Т. о., С. ф. детектора, равномерно освещаемого светом пост. интенсивности, совпадает со статистикой *дровового шума*.

Если интенсивность излучения флуктуирует во времени и пространстве (т. е. сама является случайным процессом), выражение для распределения фотоотсчетов включает в себя усреднение по этим флуктуациям с помощью распределения энергии излучения $P(Q)$:

$$P_m(t, T) = \int_0^{\infty} P(Q)(m!)^{-1} (\eta Q / \hbar \omega)^m \exp(-\eta Q / \hbar \omega) dQ. \quad (3)$$

Факториальные моменты распределения (3) определяются моментами распределения $P(Q)$:

$$\langle m(m-1) \dots (m-k+1) \rangle = (\eta / \hbar \omega)^k \langle Q^k \rangle \equiv \\ \equiv (\eta / \hbar \omega)^k \int_0^{\infty} P(Q) Q^k dQ,$$

и дисперсия числа отсчетов $\langle \Delta m^2 \rangle$ в этом случае больше ср. значения $\langle m \rangle$, т. е. распределение $P_m(t, T)$ в отличие от пуассоновского. Отличие распределения (3) от пуассоновского содержит информацию о характере распределения энергии света $P(Q)$ и поэтому представляет практич. ценность. Наиб. информативности достигают, когда приемная площадка счётчика меньше площади когерентности излучения, а время измерения T не превосходит времени когерентности. Тогда энергия Q практически совпадает (с точностью до множителя) с мгновенным значением интенсивности $Q \approx ITS$, и распределение фотоотсчетов содержит распределение интенсивности излучения $P(I)$:

$$P_m(T) = \int_0^{\infty} P(I)(m!)^{-1} (\eta ITS / \hbar \omega)^m \exp(-\eta ITS / \hbar \omega) dI. \quad (4)$$

Соотношение (4) используется на практике для анализа распределения интенсивности света $P(I)$ по данным о распределении фотоотсчетов. В частности, моменты распределения интенсивности рассчитываются по величинам факториальных моментов распределения отсчетов $P_m(T)$:

$$\langle I^k \rangle = \int_0^{\infty} P(I) I^k dI = \langle m(m-1) \dots (m-k+1) \rangle (\hbar \omega / \eta TS)^k.$$

Хотя полное восстановление распределения интенсивности света по данным о распределении фотоотсчетов проблематично из-за неизбежных погрешностей измерения $P_m(T)$, взаимосвязь (4) пригодна для проверки разл. статистич. гипотез о $P(I)$.

Если фотоотсчетов. площадка счётчика велика по сравнению с площадью когерентности излучения и (или) время измерения T больше времени когерентности, то это соответствует малым флуктуациям падающей энергии Q около своего ср. значения и С. ф. приближается к пуассоновской, независимо от свойств света.

Соотношения (1) — (4) связывают С. ф. $P_m(t, T)$ со свойствами излучения, если применимо классич. описание света и можно говорить об интенсивности излучения и его энергии вне связи с процессом фотодетектирования. В этом пределе С. ф. не может быть субпуассоновской, т. е. дисперсия $\langle \Delta m^2 \rangle$ не меньше ср. значения $\langle m \rangle$. Более общие квантовые соотношения, описывающие С. ф., снимают это ограничение. В квантовой оптике распределение фотоотсчетов связано с оператором плотности излучения $\hat{\rho}$ через операторы положительной \hat{E}_+ и отрицательной \hat{E}_- частотных частей эл. поля (см. *Когерентное состояние, Квантовая когерентность*) [5]:

$$P_m(t, T) = \text{Sp} \left\{ \hat{\rho} \hat{N}(m!)^{-1} \left[\eta \int_0^t \int_S \hat{E}_-(t', x, y) \hat{E}_+(t', x, y) \times \right. \right. \\ \left. \left. \times dt' dx dy \right]^m \exp \left[-\eta \int_0^t \int_S \hat{E}_-(t', x, y) \hat{E}_+(t', x, y) dt' dx dy \right] \right\}, \quad (5)$$

Здесь Sp — след соответствующей матрицы, а оператор нормального упорядочения \hat{N} располагает операторы \hat{E}_- слева от оператора \hat{E}_+ . В наб. важном с практич. точки зрения случае, когда фотоотсчетов. площадка счётчика меньше площади когерентности излучения $S_{\text{ног}}$, а время T не превосходит времени когерентности $T_{\text{ног}}$, допустимо одномодовое описание светового поля в области счётчика и соотношение (5) принимает вид:

$$P_m(T) = \text{Sp} \left\{ \hat{\rho} \hat{N}(m!)^{-1} (\eta' \hat{a}^+ \hat{a}^-)^m \exp(-\eta' \hat{a}^+ \hat{a}^-) \right\} \equiv \\ \equiv \sum_{n \geq m} P_n [n! / m! (n-m)!] (\eta')^m (1 - \eta')^{n-m}, \quad (6)$$

где \hat{a}^+ и \hat{a}^- — операторы рождения и уничтожения фотонов в рассматриваемой моде, а оператор нормального упорядочения \hat{N} располагает \hat{a}^+ слева от \hat{a}^- . Выражение (6) связывает распределение фотоотсчетов $P_m(T)$ с квантовоопт. характеристикой излучения $P_n \equiv \text{Sp} \{ \hat{\rho} |n\rangle \langle n| \} \equiv \langle n | \hat{\rho} |n\rangle$ — распределение числа фотонов в объёме когерентности излучения $T_{\text{ног}} S_{\text{ног}}$. Эффективность детектирования η' в (6) отличается от физ. квантовой эффективности счётчика η множителем: $\eta' = \eta T / T_{\text{ног}} S_{\text{ног}}$. Переход от квантовых соотношений к классич. пределу осуществляется заменой $\hat{a}^+ \hat{a}^-$ на $ITS_{\text{ног}}$.

Когерентное излучение, наиб. близкое к классич. пределу, имеет пуассоновское распределение числа фотонов

$$P_n = \langle n \rangle^n e^{-\langle n \rangle} / n!$$

и распределение фотоотсчетов также пуассоновское:

$$P_m(T) = (\eta' \langle n \rangle)^m e^{-\eta' \langle n \rangle} / m!$$

со ср. числом отсчетов $\langle m \rangle = \eta' \langle n \rangle$.

Для света с заданным числом фотонов n_0 распределение явно не классическое: $P_n = \delta_{n, n_0}$ и распределение фотоотсчетов биномиальное:

$$P_m(T) = (\eta')^m (1 - \eta')^{n_0 - m} n_0! / (m! (n_0 - m)!), \quad m \leq n_0.$$

Такое распределение всегда субпуассоновское, поскольку его дисперсия $\langle \Delta m^2 \rangle = \eta' (1 - \eta') n_0$ меньше ср. числа отсчетов $\langle m \rangle = \eta' n_0$.

Для одномодового теплового поля вероятностное распределение задаётся степенным выражением (*Бозе — Эйнштейна статистика*):

$$P_n = \langle n \rangle^n / (1 + \langle n \rangle)^{n+1};$$

распределение фотоотсчетов также степенное:

$$P_m(T) = (\eta' \langle n \rangle)^m / (1 + \eta' \langle n \rangle)^{m+1}$$

со средним $\langle m \rangle = \eta' \langle n \rangle$.

Т. о., измерение распределения фотоотсчетов $P_m(T)$ позволяет восстанавливать распределение числа фотонов излучения P_n . Если квантовая эффективность счётчика высока $\eta \approx 1$, а $S \approx S_{\text{ног}}$ и $T \approx T_{\text{ног}}$, то распределения P_n и $P_m(T)$ мало отличаются друг от друга. Однако такие условия трудно реализовать из-за низких квантовых эффективностей счётчиков фотонов. В случае малых η восстановить P_n по распределению фотоотсчетов нетривиально вследствие ограниченной точности данных о $P_m(T)$, получаемых из измерений. Кроме того, задача усложняется др. погрешностями

счётчиков: случайными сбравываниями, не связанными с приходом фотонов (темновой ток), мёртвым временем счётчиков (несобственностью их к сбравыванию в течение некоего интервала времени после предыдущего отсчёта) и др.

С. ф. применяется в исследованиях затухания люминесценции вещества после её кратковрем. возбуждения (напр., коротким световым импульсом) методом «стартового» и «стопового» импульсов. Излучение люминесценции вещества направляется на счётчик фотонов, и в последовательности повторяющихся актов измерения регистрируется распределение интервалов времени между моментом возбуждения люминесценции («стартовый» импульс) и моментом первого отсчёта («стоповый» импульс). Взаимосвязь распределения указанных интервалов $p(T)$ с временным ходом люминесценции $I(t)$ основывается на выражении для вероятности нулевого числа фотоотсчётов (1), поскольку до первого отсчёта счётчик «молчит»:

$$P_0(0, T) = \exp\left[-\eta S \int_0^T I(t') dt'\right]. \quad (7)$$

В момент старта $t = 0$, а T — интервал времени до первого фотоотсчёта. Вероятность отсутствия фотоотсчётов (7) уменьшается с ростом T благодаря росту вероятности первого отсчёта, поэтому для распределения интервалов T по действительности справедливо:

$$p(T) \sim -\frac{\partial}{\partial T} P_0(0, T) = \\ = [\eta S I(T)/h\omega] \exp\left[-\eta S \int_0^T I(t') dt'/h\omega\right].$$

Измерения интервалов организованы так, чтобы вероятность отсчётов была мала:

$$\eta S \int_0^T I(t') dt'/h\omega \ll 1 \text{ и } \exp\left[-\eta S \int_0^T I(t') dt'/h\omega\right] \approx 1;$$

распределение интервалов $p(T)$ в этом случае просто повторяет ход затухания люминесценции: $p(T) \sim I(T)$. Метод «стартового» и «стопового» импульсов в исследованиях люминесценции веществ широко используется в связи с развитием техники лазерной генерации ультракоротких световых импульсов (длительностью $\leq 10^{-10}$ с), необходимых для кратковрем. возбуждения люминесценции.

Ещё одним примером использования С. ф. для изучения когерентных свойств света является опыт Брауна — Твисса (6), в к-ром анализируются совпадения фотоотсчётов двух счётчиков, расположенных в одном световом поле (см. *Интерферометр интенсивности*). В ряде случаев этот опыт позволяет измерить время когерентности излучения.

Лит.: 1) Л о у д о в а Р., Квантовая теория света, пер. с англ., М., 1976; 2) К л а н и о Д. Н., Физические основы квантовой электроники, М., 1986; 3) П е р и н а Я., Квантовая статистика линейных и нелинейных оптических явлений, пер. с англ., М., 1987; 4) М а н д е л Л., Fluctuations of photon beams and their correlations, «Proc. Phys. Soc.», 1958, т. 72, р. 1037; 5) то же, Fluctuations of photon beams. The Distribution of photoelectrons, «Proc. Phys. Soc.», 1959, в. 74, р. 233; 6) К е л л и Р. Л., К л е й н Е. Н., Theory of electromagnetic field measurement and photoelectron counting, «Phys. Rev.», 1964, т. А 138, р. 316; 7) Г р о в н Н. Р., Т w i s s Р. Q., Interferometry of the intensity fluctuations in light, I and II, «Proc. Roy Soc.», 1957, в. А 242, р. 300, 1958, в. А 243, р. 291.

А. В. Масолов.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА — предположение о законе распределения изучаемых случайных величин или событий. Это понятие встречается в задаче анализа данных при статистической проверке гипотез. В теории статистич. проверки гипотез рассматриваются, как эксперим. данные могут быть использованы для выбора одной из альтернативных гипотез либо для того, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию (гипоте-

зу). Решение принимается с помощью статистического критерия. Последний строится на анализе поведения проверочной статистики, являющейся функцией наблюдений и проверяемой гипотезы.

Лит.: М и т р о п о л с к и й А. К., Техника статистических вычислений, 2 изд., М., 1971; Статистические методы в экспериментальной физике, пер. с англ., М., 1976.

В. П. Якузов, С. В. Калмыков.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА — то же, что матрица плотности.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА — то же, что статистическая физика. Термин «С. м.» введён Дж. У. Гиббсом (J. W. Gibbs). Иногда под С. м. в более узком смысле слова понимают те разделы статистич. физики, к-рые основаны на методе Гиббса, использующего для описания физ. систем представления о фазовом пространстве и статистических ансамблях.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА — теория, описывающая свойства возбуждённых состояний ядер с помощью методов статистической физики. С. м. я. применима для достаточно больших энергий возбуждения \mathcal{E} , когда уровни составного ядра (компаунд-ядра) или перекрыты, или расположены достаточно густо, так что можно использовать понятия плотности уровней $\rho(\mathcal{E})$, ядерной темп-ры $T(\mathcal{E})$ и т. н. В случае перекрытых уровней С. м. я. применяется обычно при вычислениях характеристик, усреднённых по достаточно большому интервалу энергий возбуждения ($\mathcal{E} - \Delta\mathcal{E}, \mathcal{E} + \Delta\mathcal{E}$), в к-ром есть хотя бы нек. отдельные компаунд-ядерных состояний. Т. к. учёт взаимодействия между нуклонами не изменяет общего числа степеней свободы системы, то в качестве С. м. я. можно приближённо использовать модель ферми-газа. Для ядра с $N = Z = A/2$, где N — число нейтронов, Z — число протонов в ядре, A — массовое число, в модели ферми-газа справедливы соотношения:

$$\rho(\mathcal{E}) = \frac{1}{12\mathcal{E}} \sqrt{\frac{6}{\pi^2 g_F \mathcal{E}}} \exp[2(\pi^2 g_F \mathcal{E}/6)^{1/2}]. \quad (1)$$

Темп-ра ядра равна обратной величине логарифмич. производной от ρ :

$$T(\mathcal{E}) = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial \mathcal{E}}\right)^{-1} = \left\{ \left[(\pi^2 g_F \mathcal{E}/6)^{1/2} - 5/4 \mathcal{E} \right]^{-1} \right\}. \quad (2)$$

Здесь g_F — плотность одночастичных уровней на поверхности Ферми:

$$g_F \approx 1,5A \mathcal{E}_F, \quad (3)$$

где \mathcal{E}_F — энергия Ферми.

Условие применимости С. м. я. служит неравенство $\mathcal{E}_F A^{1/3} \ll \mathcal{E} \ll \mathcal{E}_F A^{-1}$. При этом из (2) следует: $\mathcal{E} \approx \pm 1,5 g_F T^2$. Модель ферми-газа позволяет вычислить плотность уровней ρ с фиксиров. угл. моментом I в зависимости $\pi(I)^2$:

$$\rho(\mathcal{E}, I) = \frac{\pi}{48\sqrt{6}} g_F (2I + 1) (g_F h^2 \pi)^{1/2} \left[\mathcal{E} - h^2 \pi^2 (I + 1/2) \right]^{-1/2} \times \\ \times \exp\left\{ 2 \left[\frac{\pi^2}{6} g_F \left(\mathcal{E} - \frac{h^2}{2J} I(I + 1) \right) \right]^{1/2} \right\}. \quad (4)$$

Здесь J — твердотельный момент инерции ядра:

$$J = (2/3) \int n(r) r^2 dr, \quad (5)$$

где $n(r)$ — нуклонная плотность. Т. о., при усреднении по группе состояний с одним и тем же угл. моментом I проявляется свойство вращения, хотя каждое из них не было вращательным состоянием ядра (вращение нагретого ядра). Ядерная темп-ра определяет ширину размаха ферми-ступенек в распределении нуклонов по импульсам. Поэтому число возбуждённых нуклонов в модели ферми-газа, определяемое числом уровней в интервале $\sim T$, равно $n_{\text{возб}} \sim g_F T$. Для применимости С. м. я. необходимо условие $n_{\text{возб}} \gg 1$. Для средних и тяжёлых ядер $g_F \approx 5 - 10 \text{ МэВ}^{-1}$, так что

это условие выполняется при $T \geq 0,5-1$ Мэв, $\rho \geq 1-5$ Мэв. С. м. я. часто используют в области т. и. нейтронных резонансов $\rho \approx 8$ Мэв (см. *Нейтронная спектроскопия*).

Разл. поправки к модели ферми-газа обусловлены корреляциями нуклонов (NY -корреляции). Часто, оставляя для $\rho(\mathcal{E})$ вид (1), величину g_F считают феноменологич. параметром, отличным от значения, даваемого соотношением (3). Наиб. существ. поправки к функциональному виду (1) вызваны эффектами *сверхтекучести* и существенны для темп-р $T \Delta \approx 1$ Мэв, где Δ — энергетич. щель (см. *Сверхтекучесть атомных ядер*).

Более детально картину статистич. свойств ядерных уровней даёт изучение корреляций между их разл. свойствами. Так, вероятность P_n того, что соседние уровни с одинаковыми l разделены интервалом s , для неважнодействующих нуклонов даётся *Пуассона распределением*:

$$P_n^0 = (1/D) \exp(-s/D), \quad (6)$$

а с учётом взаимодействия — распределением Вигнера:

$$P_n^w = (\pi s/2D^2) \exp(-\pi s^2/4D^2).$$

Здесь D — ср. расстояние между уровнями. Т. о., учёт взаимодействия приводит к «расталкиванию» уровней: $P_n^0 = 0$, тогда как $P_n^w = 1/D$.

С. м. я. широко применяются при описании *ядерных реакций*, в теории *деления ядер* и др.

Лит. см. при ст. *Ядро атомоэ.* Э. Е. Сергеевичев.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОПТИКА — раздел оптики, изучающий оптич. явления и процессы, для описания к-рых используются статистич. понятия и стохастич. методы анализа. С. о. включает большой круг проблем: изучение шумов и флуктуаций в источниках оптич. излучения, статистич. проблемы взаимодействия световых полей с веществом, исследование распространения оптич. волн в случайно неоднородных и турбулентных средах, статистич. проблемы приёма и обработки информации в оптич. диапазоне длин волн и т. п.

Историю развития С. о. можно условно разделить на три периода: долазерный, лазерный и постлазерный, или новейший. До создания лазеров источники света были по существу шумовыми, к-рые адекватно описываются гауссовой статистикой (см. *Белый свет*). Лазеры излучают свет, как правило, с значительно подавленными флуктуациями и во мн. случаях хорошо описываются моделью излучения с практически пост. амплитудой, но случайной фазой. Лазерные поля имеют существенно негауссовую статистику и могут быть описаны как квантовомеханически, так и полуклассически. В постлазерный период были созданы источники неклассич. световых полей; в 1977 — поля с антигруппировкой фотонов (см. *Квантовая оптика*), в 1985 — поля в квантовом сжатом состоянии (см. *Сжатое состояние света*). В зависимости от методов, применяемых для описания случайных оптич. процессов и явлений, различают волновую С. о. и квантовую С. о. Статистич. явления, связанные с регистрацией светового поля методом счётв отд. фотонов, относятся к *статистике фотоисчислений*.

Ниже рассмотрены осн. вопросы волновой С. о.; проблемы квантовой С. о. обсуждаются в ст. *Квантовая оптика, Квантовая когерентность*.

Теория когерентности. В теории когерентности статистич. свойства световых полей описываются пространственно-временными корреляц. ф-циями (ф-циями когерентности) разл. порядка (см. *Когерентность света*). Наиб. практич. интерес представляют корреляц. ф-ции 2-го порядка, к-рые непосредственно связаны с интерференционными схемами Юнга и Майкельсона,

используемыми для получения информации о пространственной и временной когерентности. Корреляц. ф-ция поля 2-го порядка исследуется амплитудной интерферометрией. Поляризац. свойства света описываются с помощью поляризац. матрицы, составленной из корреляц. ф-ций 2-го порядка между ортогональными компонентами поля. Вид корреляц. ф-ций 2-го порядка не зависит от статистики поля и определяется лишь углами и частотным спектром излучения.

Корреляц. ф-ция поля 4-го и более высокого порядка, описывающие интерферометрию интенсивности (см. *Интерферометр интенсивности*), уже содержит информацию и о статистич. свойствах поля. Так, для полей с группировкой фотонов корреляц. ф-ция интенсивности 4-го порядка монотонно падает, а для полей с антигруппировкой фотонов эта ф-ция сначала нарастает, а затем падает. Амплитудная интерферометрия и интерферометрия интенсивности используются для спектроскопич. целей и получения информации об изображении.

Флуктуации и шумы в лазерах. Тепловые шумы оптич. резонатора и спонтанное излучение атомов (молекул) активной среды являются принципиально неустранимыми источниками шума в лазерах. Шумы приводят к естеств. флуктуациям амплитуды и фазы одночастотного и одномодового лазера, вследствие к-рых существуют предельные значения временных и пространственных статистич. характеристик лазерного излучения: естеств. ширина частотного спектра, определяемая ф-лой Шавлова — Таунса [ф-ла (8) в ст. *Лазер*]; естеств. угол расходимости, предельная пространственная когерентность. В режиме генерации нескольких несинхронизованных (несвязанных) продольных и (или) поперечных мод статистика излучения существенно меняется: она становится практически гауссовой. Исследование флуктуаций в лазерах представляет интерес для анализа динамики его излучения; знание статистич. свойств лазерного излучения определяет возможности использования лазеров в разл. приложениях.

Нелинейная статистическая оптика. Статистич. задачи в волновой оптике могут быть связаны как со статистикой излучения (нелазерные источники, лазерное излучение с несинхронизов. модами и т. п.), так и со статистикой среды (собств. эл.-магн. флуктуации в среде, статистически неоднородные среды, кристаллич. порошки и т. п.). Случайная модуляция волн может существенно влиять на протекание нелинейных оптич. процессов, изменяя характер и эффективность взаимодействия. При наличии случайной временной модуляции существует т. н. когерентная длина, определяемая расстройкой групповых скоростей (см. *Групповая синхронизм*) и шириной спектра или временем корреляции шумовой волны, при превышении к-рого нелинейные когерентные взаимодействия становятся некогерентными. Это проявляется, напр., в темпе накопления нелинейного эффекта. В пространственных задачах когерентная длина определяется двулучепределением анизотропного нелинейного кристалла и радиусом корреляции случайной волны. При нелинейном взаимодействии случайных и шумовых волн интерес представляет реализация условий, при к-рых эффективность шумовой накачки может приближаться к эффективности монохроматич. накачки такой же ср. интенсивности или даже превышать её. Методами нелинейной оптики можно получить случайные пучки с фазой, комплексно сопряжённой с исходной (см. *Обращение еванового фронта*).

Изучение нелинейных оптич. процессов в статистически неоднородных средах позволяет определить влияние неоднородностей на эффективность процессов (генерация гармоник, параметрич. взаимодействия и т. д.) и оценить возможность подавления разл. вредных неустойчивостей (линейных и нелинейных). Последние приводят к флуктуациям коэф. нелинейной связи

волн. Флуктуация показателя преломления среды вызывают случайный сбой фазового соотношения (см. *Фазовой синхронизации*) между взаимодействующими полями и, следовательно, уменьшают эффективность нелинейной взаимодвижности.

Распространение — это световые волны в случайно неоднородных средах. Это направление С. о. обычно выделяется в самостоятельный раздел. Пространственная и временная когерентность лазерных пучков при распространении в случайно неоднородных и турбулентных средах ухудшается. Прошедшие через такие среды лазерные пучки содержат информацию о свойствах самой неоднородной среды. В связи с этим лазерное излучение широко применяется для зондирования турбулентных и рассеивающих сред. Разработаны спец. методы описания распространения лазерных пучков в таких средах. Изучение влияния турбулентной атмосферы на распространение световых пучков весьма важно также для *оптической связи и оптической локации*.

Статистика фотоотсчетов. Для регистрации слабых световых потоков применяется статистич. метод счёта фотонов. В этом методе, как и любым другим, неизбежно появление флуктуаций, обусловленных квантовой природой света. Процессы поглощения фотона атомом фотоувеличат. поверхности детектора и последующее испускание электрона, регистрируемого детектором, носят принципиально статистич. характер. При пост. интенсивности регистрируемого излучения статистика фотоотсчетов — пуассоновская; в случае флуктуирующей интенсивности распределение фотоотсчетов отличается от пуассоновского и зависит от статистич. интенсивности света. Зная распределение фотоотсчетов, можно решить обратную задачу и найти статистику регистрируемого поля (подробнее см. *Статистика фотоотсчетов*).

Лит.: А х м а н о в С. А., Ч и р к и н А. С., Статистические явления в нелинейной оптике, М., 1974; Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов, под ред. Г. Камминса, Э. Пайкса, пер. с англ., М., 1978; Р ы т о в С. М., К р а в ч о в Ю. А., П л а т о н о в В. И., Введение в статистическую радиофизику, ч. 2 — Случайные поля, М., 1978; К р о с и н с к и й В. Д., Д и о р т о П., В е р т о л о г т я М., Статистические свойства рассеянного света, пер. с англ., М., 1980; А х м а н о в С. А., П л а т о н о в В. И., Ч и р к и н А. С., Введение в статистическую радиофизику и оптику, М., 1981; Г у д ж и н Г. Д., Статистическая оптика, пер. с англ., М., 1988. А. С. Чиркин.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ — задача анализа данных, в результате решения к-рой подтверждается или опровергается гипотетич. предположение (см. *Статистическая гипотеза*) о законе распределения случайной величины либо делается выбор одной из альтернативных гипотез. Решение этой задачи опирается на использование статистич. критерия, к-рый является функцией наблюдаемой случайной выборки и проверяемой гипотезы.

В. П. Жигуров, С. В. Калмыков.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — совокупность большого числа частиц (атомов, молекул и т. д.), изучаемых методами *статистической физики*. С. с. можно разделить на открытые и закрытые. Для закрытых С. с. ср. значения числа частиц, энергии, импульсы системы поддерживаются постоянными.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СУММА — величина, обратная нормирующему множителю *канонического распределения Гиббса* в квантовой статистич. физике и равная сумме по квантовым состояниям:

$$Z = \sum_n \exp(-E_n/kT),$$

где E_n — энергия системы в квантовом состоянии n , T — абс. темп-ра. Суммирование производится по всем допустимым n (в т. ч. по состояниям с одинаковой энергией). С. с. позволяет вычислить все *потенциалы термодинамические*, в частности свободную энергию (Гельмгольца энергию) $F = -kT \ln Z$ как ф-цию темп-ры, объема и числа частиц в зависимости от потенциала взаимодействия частиц. Если известны гамма-д

тонная системы Π , то $Z = \text{Sp} \exp(-H/kT)$. Для идеального газа

$$Z = \sum_{(n_i)} \exp \left[- \sum_i n_i \epsilon_i / kT \right],$$

причём суммирование ведётся при дополнит. условии $\sum_i n_i = N$ (N — полное число частиц). Суммирование

в показателе экспоненты проводится по всем одночастичным квантовым состояниям ϵ_i с энергией ϵ_i ; $\{n_i\}$ — возможный набор значений n_i , по к-рым ведётся суммирование. Для *Бозе — Эйнштейна статистики* $n_i = 0, 1, 2, \dots$. Для *Ферми — Дирака статистики* n_i может быть 0 или 1. В классич. статистич. физике С. с. соответствует *статистической интерпретации* Д. Н. Зубарев. **СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ** — то же, что *термодинамическая теория возмущений*.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА (равновесная статистическая термодинамика) — раздел *статистической физики*, посвященный обоснованию законов *термодинамики* равновесных процессов (на основе статистич. механики Дж. У. Гиббса, J. W. Gibbs) и вычислением термодинамич. характеристик физ. систем (*потенциалы термодинамические* и др.), *урянения состояния* на основе законов взаимодействия составляющих эту системы частиц. Неравновесная С. т. даёт статистич. обоснование *термодинамики неравновесных процессов* (ур-ний переноса энергии, импульса, массы) и позволяет получить выражения для входящих в ур-ния переноса коэффициентов (кинетич. коэф.) на основе законов взаимодействия и движения частиц системы.

Лит.: Л а н д а у Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Статистическая физика, ч. 3, 2 изд., М., 1978; М а л е в с к и й Г. Г., Г е л с е р т М а я с е р М., Статистическая механика, пер. с англ., 2 изд., М., 1980; З у б а р е в Д. Н., Неравновесная статистическая термодинамика, М., 1971; см. также лит. при ст. *Статистическая физика*.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА — раздел физики, задача к-рого — выразить свойства макроскопич. тел, т. е. системы, состоящих из очень большого числа одинаковых частиц (молекул, атомов, электронов и т. д.), через свойства этих частиц и взаимодействие между ними.

Т. о., в С. ф. используются сведения о «микроскопическом» строении тел, поэтому С. ф. является микроскопич. теорией. В этом её отличие от др. разделов физики, также изучающих макроскопич. тела: термодинамики, механики и электродинамики сплошных сред. При решении конкретных задач методами этих дисциплин и соответствующие ур-ния всегда входят известные параметры или ф-ции, характеризующие данное тело. Все эти зависимости и параметры можно определять экспериментально, поэтому методы, о к-рых идёт речь, баз. феноменологическими. С. ф. позволяет, по крайней мере в принципе, а во мн. случаях и фактически, вычислить эти величины.

Если в какой-то момент времени заданы координаты и скорости всех частиц тела и известен закон их взаимодействия, то из ур-вий механики можно было бы найти координаты и скорости в любой последующий момент времени и тем самым полностью определить состояние тела. Такая же ситуация имеет место и в квантовой механике: зная изначально волновую ф-цию системы, можно, решая ур-ние Шрёдингера, найти волновую ф-цию, определяющую состояние системы во все будущие моменты времени.

Реально такой путь построения микроскопич. теории невозможен, т. к. число частиц в макроскопич. телах очень велико, а нач. координаты и скорости молекул неизвестны. Однако именно большое число частиц в макроскопич. телах приводит к появлению новых (статистич.) закономерностей в поведении таких тел. Эти закономерности выявляются после соот-

ветствующего ограничения задач теории. Характеризующие макроскопич. тела параметры испытывают с течением времени беспорядочные малые колебания (флуктуации) относительно нек-рых ср. значений. Задачей теории является вычисление этих ср. значений, а не точных значений параметров в данный момент времени. Наличие статистич. закономерностей выражается в том, что поведение ср. значений в широких пределах не зависит от конкретных нач. условий (от точных значений нач. координат и скоростей частей). Важнейшее проявление этой закономерности — известный из опыта факт, что система, изолированная от внеш. воздействий, с течением времени приходит в нек-рое равновесное состояние (термодинамич. равновесие), свойства к-рого определяются только такими общими характеристиками нач. состояния, как число частиц, их суммарная энергия и т. н. (см. *Равновесие термодинамическое*). Процесс перехода системы в равновесное состояние наз. *релаксацией*, а характерное время этого процесса — *временем релаксации*.

Функция распределения. Рассмотрим систему, состоящую из N частиц, для простоты считая, что частицы не имеют внутр. степеней свободы. Такая система описывается заданием $6N$ переменных: $3N$ координат x_i и $3N$ импульсов p_i частиц, совокупности этих переменных сокращённо обозначим (p, x) .

Понятие *функции распределения* естественно возникает, если рассмотреть пространство $6N$ измерений, соответствующее значениям координат и импульсов частиц; оно наз. *фазовым пространством*. Каждому моменту времени t соответствуют определ. значения всех x и p , т. е. нек-рая точка в фазовом пространстве, изображающая состояние системы в данный момент. С течением времени значения x и p меняются, так что точка в фазовом пространстве движется.

Выясним ср. значение \bar{f} по заданному интервалу времени нек-рой ф-ции координат и импульсов $f(x, p)$. Для этого выберем на этом интервале s моментов времени t_a , разделённых равными промежутками, им соответств. s точек в фазовом пространстве. Разобьём всё фазовое пространство на элементы, размер к-рых мал по сравнению с характерными для системы значениями x и p , но ещё настолько велик, что в каждом из них находится много точек, изображающих состояние системы в моменты времени t_a . Тогда число таких точек в элементе объёма будет примерно пропорционально величине этого объёма $dx dp$. Если обозначить коэф. пропорциональности, т. е. плотность числа точек в пространстве, через $w(x, p)$, то число точек для элемента с центром в нек-рой точке (x, p) запишется в виде:

$$dv = sw(x, p) dx dp, \quad (1)$$

где $dx dp = dx_1 dp_1 dx_2 dp_2 \dots dx_{3N} dp_{3N}$ — объём выбранного элемента фазового пространства. Ср. значение \bar{f} , вычисленное по определению

$$\bar{f} = s^{-1} \sum_{a=1}^s \int f(x(t_a), p(t_a)),$$

с учётом малости этих элементов объёма можно переписать как

$$\bar{f} = \int f(x, p) w(x, p) dx dp \quad (2)$$

(интегрирование по координатам производится по всему объёму системы, по импульсам — от $-\infty$ до ∞). Ф-ция $w(x, p)$ наз. *ф-цией распределения* по координатам и импульсам частиц. Поскольку полное число выбранных точек равно s , ф-ция w удовлетворяет условию нормировки:

$$\int w(x, p) dx dp = 1. \quad (3)$$

Из (2) и (3) видно, что $w dx dp$ можно рассматривать как вероятность того, что система находится в элементе $dx dp$ фазового пространства.

Если система не находится в состоянии термодинамич. равновесия, ф-ция распределения зависит, кроме x и p , от времени t . В этом случае следует считать, что интервал усреднения мал по сравнению со временем релаксации.

Введённый таким образом ф-ция распределения можно вл. и др. истолкование. Для этого рассмотрим одновременно большое число одинаковых систем и примем, что каждая точка в фазовом пространстве изображает состояние одной такой системы. Тогда усреднение по времени можно понимать как усреднение по совокупности этих систем, или, как говорят, по *статистическому ансамблю*.

Распределение Гиббса. Проведённые до сих пор рассуждения носили формальный характер, т. к. нахождение ф-ции распределения, согласно (1), требует знания всех x и p во все моменты времени, т. е. решения у-ний движения с соответствующими нач. условиями. Осн. положением С. ф. является утверждение о возможности из общих соображений определить эту ф-цию для системы, находящейся в состоянии термодинамич. равновесия. Прежде всего, исходя из сохранения числа частиц при движении, можно показать, что ф-ция распределения является интегралом движения системы (см. *Лиувилля теорема*).

При движении замкнутой системы её энергия не меняется, поэтому все точки в фазовом пространстве, изображающие состояние системы в разные моменты времени, должны лежать на нек-рой гиперповерхности, соответствующей нач. значению энергии E . У-ние этой поверхности имеет вид $H(x, p) = E$, где $H(x, p)$ — *Гамильтона функция* системы. Движение системы из мн. частиц носит крайне запутанный характер, поэтому с течением времени точки, описывающие состояние, распределяются по поверхности пост. энергии равномерно (см. также *Эргодическая гипотеза*). Такое равномерное распределение описывают ф-цией распределения

$$w(x, p) = \delta[H(x, p) - E], \quad (4)$$

где $\delta[H(x, p) - E]$ — дельта-функция, отличная от нуля только при $H = E$, A — постоянная, определяемая из условия нормировки (3). Ф-ция распределения (4), соответствующая *микромеханическому распределению Гиббса*, позволяет вычислять ср. значения всех физ. величин по ф-ле (2), не решая у-ний движения.

При выводе выражения (4) предполагалось, что единственная сохраняющаяся величина, от к-рой зависит w , — это энергия системы. Разумеется, сохраняются также импульс и момент импульса, но эти величины можно исключить, предположив, что рассматриваемое тело заключено в неподвижный ящик, к-рому частицы могут отдавать импульс и момент.

Фактически в С. ф. обычно рассматривают не замкнутые системы, а макроскопич. тела, являющиеся малыми макроскопич. частями, или подсистемами, к.-л. замкнутой системы. Ф-ция распределения для подсистемы отлична от (4), но не зависит от конкретного вида остальной части системы, т. н. термостата. Для определения ф-ции распределения подсистемы необходимо проинтегрировать ф-лу (4) по импульсам и координатам частиц термостата. Такое интегрирование можно произвести, учитывая малость энергии подсистемы по сравнению с энергией термостата. В результате для ф-ции распределения подсистемы получаются выражения

$$w(x, p) = \exp\{[F - H(x, p)]/kT\}, \quad (5)$$

величина T в этой ф-ле имеет смысл темп-ры. Нормировочный коэф. $\exp(F/kT)$ определяется из условия нормировки (3):

$$\exp(-F/kT) = Z = \int \exp[-H(x, p)/kT] dx dp. \quad (6)$$

Распределение (5) наз. *каноническим распределением Гиббса* или просто *канонич. распределением* (см. *Гиббса распределение*), а величина Z — статистич. интегралом. В отличие от микроканонич. распределения, в канонич. распределении энергия системы ее задана. Состояния системы сосредоточены в тонком слое конечной толщины вокруг энергетич. поверхности, соответствующей ср. значению энергии, что означает возможность обмена энергией с термостатом. В остальном в применении к определ. макроскопич. телу оба распределения приводят по существу к одним и тем же результатам. Различие состоит лишь в том, что при использовании микроканонич. распределения все ср. значения оказываются выраженными через энергию тела, а при использовании канонич. распределения — через темп-ру.

Если тело состоит из двух взаимодействующих частей 1 и 2 с ф-циями Гамильтона H_1 и H_2 , то для всего тела $H = H_1 + H_2$ и, согласно (5), ф-ция распределения тела разбивается на произведение ф-ций распределения для каждой из частей, так что эти части оказываются статистически независимыми. Это требование вместе с теоремой Лиувилля можно положить в основу вывода распределения Гиббса, не обращаясь к микроканонич. распределению.

До сих пор мы говорили о системах, описываемых классич. механикой. В квантовой механике роль ф-ции распределения играет *статистический оператор* (статистич. матрица) $\rho(x, x')$. Ср. значения физ. величин выражаются через него ф-лой, аналогичной ф-ле (2) классич. теории:

$$f = \int \hat{f} \rho(x, x') dx,$$

где \hat{f} — квантовомеханич. оператор величины f , действующий на координаты x . Характерной особенностью квантовой механики является дискретность энергетич. спектра системы конечного объема. Вероятности того, что подсистема находится в квантовом состоянии с энергией E_n , в термодинамич. равновесии определяются ф-лой, аналогичной (5):

$$w_n = \exp\{-(E_n - E_0)/kT\}, \quad (7)$$

причем условие нормировки $\sum_n w_n = 1$ можно переписать в виде:

$$\exp(-F/kT) = Z = \sum_n \exp(-E_n/kT). \quad (8)$$

Величина Z наз. *статистической суммой* системы; сумма в выражении (8) берется по всем состояниям системы. В операторном виде ф-лу (8) можно переписать как $Z = \text{Sp} \exp(-\hat{H}/kT)$, где \hat{H} — *гамильтониан* подсистемы.

Энергетич. спектр макроскопич. тела фактически является очень густым, поэтому целесообразно в ф-ле (8) перейти от суммирования к интегрированию, введя плотность числа состояний $g(E)$, так что $g(E)dE$ есть число состояний в интервале энергий dE , тогда

$$Z = \int_0^{\infty} g(E) \exp(-E/kT) dE.$$

Статистич. матрица в состоянии равновесия имеет вид:

$$\rho(x, x') = \sum_n w_n \Psi_n(x) \Psi_n^*(x'),$$

где $\Psi_n(x)$ — волновая ф-ция стационарного состояния подсистемы с энергией E_n .

Для системы, с достаточной точностью описываемой классич. механикой, в ф-ле (8) можно перейти от суммирования по состояниям к интегрированию по координатам и импульсам системы. При этом на каждое квантовое состояние приходится в фазовом пространстве «ячейка» объемом h^{3N} . Иными словами, суммирование по N сводится к интегрированию по $dx dp/h^{3N}$. Следует также учесть, что ввиду тождественности частиц в квантовой механике при их перестановке состояние системы не меняется. Поэтому, если интегрировать по всем x и p , необходимо поделить интеграл на число перестановок из N частиц, т. е. на $N!$. Окончательно классич. предел для статистич. суммы имеет следующий вид:

$$\exp(-F/kT) = Z = (N! h^{3N})^{-1} \int \exp[-H(x, p)/kT] dx dp, \quad (9)$$

отличающийся множителем от чисто классич. выражения (6), что приводит к дополнит. слагаемому в ф-ле для F .

Приведенные ф-лы относятся к случаю, когда число частиц в подсистеме задано. Если выбрать в качестве подсистемы определ. элемент объема всей системы, через поверхность k -рого частицы могут покидать подсистему и возвращаться в нее, то вероятность нахождения подсистемы в состоянии с энергией E_n и числом частиц N_n определяется большим каноническим распределением Гиббса:

$$w_n = \exp\{(\Omega - E_n - \mu N_n)/kT\},$$

в к-ром имеется дополнит. параметр μ — хим. потенциал, определяющий ср. число частиц в подсистеме, а величина Ω определяется из условия нормировки:

$$\exp(\Omega/kT) = \sum_n \exp[-(E_n - \mu N_n)/kT]. \quad (10)$$

Статистическое использование термодинамики. Важнейший результат С. ф. — установление статистич. смысла термодинамич. величин. Это даёт возможность вывести законы *термодинамики* из ав. представлений С. ф. и вычислять термодинамич. величины для конкретных систем. Прежде всего термодинамич. внутр. энергии отождествляется со ср. энергией системы. *Первое начало термодинамики* получает тогда использование как выражение закона сохранения энергии при движении составляющих тело частиц.

Далее, пусть гамильтониан \hat{H} системы зависит от нек-рого параметра λ (координаты стенки сосуда, в к-рый заключена система, внеш. поля и т. п.). Тогда производная $\partial \hat{H} / \partial \lambda$ является оператором *обобщенной силы*, соответствующей этому параметру, а величина $(\partial \hat{H} / \partial \lambda) d\lambda = \sum_n (\partial E_n / \partial \lambda) w_n d\lambda$ равна механич. работе,

совершаемой над системой при изменении этого параметра. Если продифференцировать выражение $\bar{E} = \sum_n E_n w_n$

для ср. энергии \bar{E} системы с учётом ф-лы (7) и условия нормировки и считать λ и T переменными, а величину F — ф-цией этих переменных, то получим тождество:

$$d\bar{E} = (\partial \hat{H} / \partial \lambda) d\lambda - T d(\partial F / \partial T).$$

Как отмечено выше, первое слагаемое справа равно ср. работе dA , совершаемой над телом, тогда второе слагаемое представляет получаемую телом теплоту. Сравнивая это выражение с соотношением

$$d\bar{E} = dA + T dS,$$

представляющим собой объединённую запись 1-го и 2-го начала термодинамики (см. *Второе начало термодинамики*) для обратимых процессов, находим, что

величина T в ф-ле (7) равна абс. темп-ре тела, а производная dF/dT — вытот с обратным знаком энтропии S . Следовательно, F — свободная энергия тела, что и выявляет её статистич. смысл. Аналогично условию нормировки (10) в большом канонич. распределении определяют термодинамич. потенциал Ω , связанный со свободной энергией соотношением: $\Omega = F - \mu N$.

Особое значение имеет статистич. использование энтропии, к-рое следует из ф-лы (8). Формально суммирование в этой ф-ле производится по всем состояниям с энергией E_n , но фактически существенно лишь относительно небольшое их число с энергией вблизи ср. энергии. Число Δn этих состояний поэтому естественно определить, ограничив суммирование в ф-ле (8) интервалом ΔE , заменив E_n на ср. энергию \bar{E} и вынося экспоненту из-под знака суммы. Тогда сумма даст Δn и ф-ла (8) примет вид: $\exp[-(F - \bar{E})/kT] = \Delta n$. С др. стороны, согласно термодинамике, $F = E - TS$, что даёт связь энтропии с числом микроскопич. состояний, иначе говоря, со *статистическим весом* макроскопич. состояния, пропорциональным его вероятности:

$$S = k \ln \Delta n. \quad (11)$$

При темп-ре абс. нуля любая система находится в определённом (основном) состоянии, так что $\Delta n = 1$, $S = 0$. Это утверждение выражает собой *третье начало термодинамики*. Здесь существенно, что для однозначного определения энтропии нужно пользоваться именно квантовой ф-лой (9); в чисто классической С. ф. энтропия определена только с точностью до произвольного слагаемого.

Смысл энтропии как меры вероятности состояния сохраняется и для неравновесных состояний. В этом случае ф-лу (11) следует рассматривать как общее определение энтропии состояния. Ясно, что в природе «самопроизвольно» (т. е. в замкнутой системе) могут идти лишь процессы, приводящие к увеличению вероятности состояния. Обратные процессы являются крайне маловероятными. [Энтропия системы пропорциональна числу частиц в ней, поэтому статистич. веса двух физических достаточно близких состояний, будучи пропорциональны $\exp(-S/k)$, различаются очень сильно.] Это даёт статистич. обоснование закону возрастания энтропии, согласно к-рому энтропия замкнутой системы может только увеличиваться. В состоянии равновесия энтропия имеет максимально возможное в данных внеш. условиях значение. Следовательно, равновесное состояние является состоянием с макс. статистич. весом, т. е. наиб. вероятным состоянием.

Из определения (11) следует, что энтропия аддитивна, т. е. энтропия тела, состоящего из слабовзаимодействующих частей, равна сумме энтропий этих частей. Это даёт возможность вычислить энтропию в важном случае, когда тело состоит из частей, к-рые находятся в равновесии сами по себе, но не друг с другом. Отметим, что ф-лы С. ф., будучи справедливы для систем из большого числа частиц, подразумевают переход к *термодинамическому пределу*, когда число частиц в теле N и объём V стремятся к бесконечности, а плотность N/V остаётся конечной. Именно в этом пределе термодинамич. потенциалы, определяемые распределением Гиббса, оказываются пропорциональными объёму.

Несмотря на ясность ф-л. основ С. ф., стремление дать ей строгое матем. обоснование поставило ряд важных и трудных матем. проблем. Напр., обоснование распределения (4) требует доказательства *эргодической гипотезы*. Методически интересен вопрос об устойчивости осн. состояния системы из большого числа частиц (электронов и ядер), взаимодействующих по закону Кулона. Процессы релаксации неравновесных состояний связаны с неустойчивостью фазаовых траекторий механ. систем, состоящей в том, что проходящие

через две близкие точки фазового пространства траектории экспоненциально расходятся по мере удаления от этих точек.

Внешние поля. Ф-ла (8), связывающая свободную энергию F со статистич. суммой, является основой для вычисления термодинамич. величин методами С. ф. Эту ф-лу используют, в частности, для построения статистич. теории электрич. и магн. свойств веществ. Напр., для вычисления магн. момента тела в магн. поле H следует вычислить статистич. сумму и свободную энергию. Магн. момент M тела выражается тогда ф-лой: $M = -dF/dH$.

При наличии слабого гравитац. поля требование максимильности энтропии приводит к след. условию равновесия:

$$\mu + m\phi = \text{const},$$

где ϕ — гравитац. потенциал, m — масса частицы. Это ур-ние описывает, напр., изменение плотности тела под действием гравитац. сил. Интересные явления должны наблюдаться в сильных гравитац. полях, когда существенны релятивистские эффекты. В таких полях, согласно общей теории относительности, в состоянии равновесия от координат зависит не только плотность, но и темп-ра тела. Известное изменение представлений С. ф. требуется, по-видимому, для последоват. описания чёрных дыр — тел, гравитац. поле к-рых настолько сильно, что световые лучи не могут выйти из их внутр. областей в окружающее пространство. Чёрная дыра испускает излучение, темп-ра к-рого однозначно связана с её радиусом. Суммарная площадь поверхности чёрных дыр может подобно энтропии только увеличиваться, чем устанавливается глубокая, но не вполне ясная связь тютюжения с законом возрастания энтропии.

Иерархия функций распределения. Кроме N -частичной ф-ции распределения w , определяемой ф-лой (1), можно ввести ф-ции более низкого порядка, получающиеся из w интегрированием по части переменных. Так, интегрируя по координатам и импульсам всех частиц, кроме одной, получаем одночастичную ф-цию $w^{(1)}(r, p, t)$, по переменным всех частиц, кроме двух, — двухчастичную ф-цию $w^{(2)}(r_1, r_2, p_1, p_2, t)$ и т. д. В состоянии равновесия, согласно ф-ле (5), зависимость w от импульсов очевидна и достаточно рассматривать лишь координатные зависимости, т. е. ф-цию $f^{(1)}(r)$, к-рая сводится для однородного тела и отсутствие внеш. поля к постоянной, $f^{(2)}(r_1, r_2)$, $f^{(3)}(r_1, r_2, r_3)$ и т. д. Все эти ф-ции стремятся при больших значениях аргументов к постоянной, к-рые можно выбрать равными 1. Существует цепочка ур-ний, связывающих ф-ции порядка i и $i+1$ (см. *Боголюбова уравнения*). Напр., для частиц, взаимодействие к-рых описывается парной потенциальной энергией $u(r)$, дифференцируя ф-лу (5) по r_2 и интегрируя по всем переменным, кроме r_1 и r_3 , получаем ур-ние

$$\frac{\partial f^{(2)}(r_1, r_2)}{\partial r_2} = -\frac{f^{(2)}(r_1, r_2)}{kT} \frac{\partial u(r_1 - r_2)}{\partial r_2} - \frac{N}{kT} \int \frac{\partial u(r_1 - r_3)}{\partial r_2} f^{(3)}(r_1, r_2, r_3) dr_3. \quad (12)$$

Если на основании допущен. соображений, связанных со спецификой конкретной проблемы, выразить $f^{(2)}$ через $f^{(1)}$, последнюю можно определить из (12). Статистич. сумма Z после этого определяется через $f^{(2)}$ простым интегрированием. В неравновесном случае аналогичные соотношения, содержащие производные по времени, можно получить для ф-ций $w^{(1)}$, $w^{(2)}$ и т. д.

Флуктуации. В основе С. ф. лежит тот факт, что физ. величинам, характеризующим макроскопич. тела, с большой точностью равны своим ср. значениям. Это равенство является всё же приближенным. В действительности все величины испытывают малые беспорядочные отклонения от ср. значений — *флуктуации*. Существо-

вание флуктуаций имеет принципиальное значение, т. к. доказывает статист. характер термодинамик. закономерностей. Кроме того, флуктуации играют роль шума, ограничивающего точность физ. измерений. Флуктуации нек-рой величины x около её ср. значения \bar{x} характеризуются ср. квадратом флуктуации $(\Delta x)^2 = (x - \bar{x})^2 = x^2 - (\bar{x})^2$. В подавляющем большинстве случаев величина x испытывает флуктуации порядка $(|\Delta x|)^{1/2}$; существенно большие флуктуации встречаются крайне редко. Знание ф-ции распределения системы позволяет вычислить ср. квадрат флуктуации точно так же, как и ср. значение любой физ. величины. Малые флуктуации термодинамик. величин можно вычислять, используя статистич. истолкование энтропии. Согласно ф-ле (11), вероятность неравновесного состояния системы с энтропией S пропорциональна $\exp(S/k)$. Это приводит к равенству

$$(\Delta x)^2 = \{(\partial^2 S / \partial x^2)_{x=\bar{x}}\}^{-1}.$$

Напр., для ср. квадратов флуктуаций объёма и темп-ры тела получим:

$$(\Delta V)^2 = -kT(\partial V / \partial P)_T, \quad \overline{(\Delta T)^2} = kT^2/c_V.$$

Из этих ф-л видно, что отност. флуктуации объёма и флуктуация темп-ры обратно пропорциональны $N^{1/2}$, где N — число частиц в теле. Это и обеспечивает малость флуктуаций для макроскопич. тел. Связь между флуктуациями разл. величин x_i, x_k характеризуется ф-цией $\Delta x_i \Delta x_k$. Если флуктуации величин x_i и x_k статистически независимы, то $\Delta x_i \Delta x_k = \overline{\Delta x_i} \overline{\Delta x_k} = 0$.

Под x_i и x_k можно понимать и значения одной и той же величины, напр. плотности, в разл. точках пространства. Т. о., приходим к пространственной корреляционной функции плотности:

$$\langle (n_1 - \bar{n})(n_2 - \bar{n}) \rangle = \bar{n}^2 [f^{(2)}(r_1 - r_2) - 1], \quad r_1 \neq r_2,$$

где n_1 и n_2 — значения плотности числа частиц в точках r_1 и r_2 , \bar{n} — ср. значение плотности, $f^{(2)}$ — введенная выше двухчастичная ф-ция распределения. С увеличением расстояния между точками корреляц. ф-ция стремится к нулю (обычно экспоненциально), т. к. флуктуации в дальних точках пространства происходят независимо. Расстояние, на к-ром эта ф-ция существенно убывает, наз. корреляц. радиусом.

Закон равнораспределения. Приложения С. ф. к изучению свойств конкретных систем сводятся к приближенному вычислению статистич. сумм с учётом специфич. свойств системы. Во мн. случаях эта задача упрощается применением закона равнораспределения по степеням свободы, утверждающего, что тепловикость c_V (при пост. объёме V) системы взаимодействующих частиц, совершающих гармонич. колебания, равна:

$$c_V = k(n + 1/2),$$

где l — общее число поступат. и вращат. степеней свободы, n — число колебат. степеней свободы. Доказательство закона основано на том, что ф-ция Гамильтона H такой системы имеет вид: $H = K(p_i) + u(x_m)$, где кинетич. энергия K — однородная квадратичная ф-ция от $l + 1$ импульсов p_i , а потенциальная энергия u — квадратичная ф-ция от l и потен. координат x_m . В статистич. интеграле (8) интегрирование по колебат. координатам ввиду быстрой сходимости интеграла можно распространить от $-\infty$ до ∞ . После этого легко показать, что внутр. энергия линейно зависит от темп-ры, откуда следует приведенное выражение для тепловикости. Отметим, что закон равнораспределения верен только в классической С. ф.

Идеальный газ. Простейшим объектом исследования в С. ф. является идеальный газ, т. е. газ настолько разреженный, что можно пренебречь взаимодействием меж-

ду его молекулами. Энергия такого газа равна просто сумме энергий отд. молекул. В классической С. ф. это означает, что ф-ция распределения распадается на произведение ф-ций распределения для отд. молекул. В дальнейшем для простоты рассматривается одноатомный газ. Энергия атома во внеш. поле с потенциальной энергией $u(r)$ равна $p^2/2m + u(r)$. Интегрируя ф-лу (5) по координатам x_i и импульсам p_i всех атомов, кроме одного, находим число атомов, импульсы к-рых лежат в элементе объёма импульсного пространства dp , а координаты — в элементе объёма dx :

$$dN = C \exp[-(p^2/2m + u(r))/kT] dp dx. \quad (13)$$

Эту ф-лу называют распределением Максвелла — Больцмана (см. *Больцмана статистика*). Статистич. интеграл (9) идеального классич. газа также распадается на произведение членов, соответствующих отд. атомам. При этом, однако, нужно учесть, что осн. состояние атома может быть вырождено, т. е. г. состояний могут иметь одинаковую энергию. Это приводит к появлению дополнит. множителя g^N в статистич. сумме. Обобщательно свободная энергия N атомов газа равна:

$$F = -NkT \ln \{ (mkT/2\pi\hbar^2)^{3/2} eVg/N \},$$

здесь V — объём газа, g — оснвание натуральных логарифмов. При высоких темп-рах $g = (2J + 1)(2L + 1)$, где J — величина спина, а L — орбитальный момента атома (в единицах \hbar). Из выражения для свободной энергии следует, что зависимость давления P идеального газа от плотности числа частиц (N/V) и темп-ры имеет вид: $PV = NkT$. Для внутр. энергии одноатомного газа, его тепловикости при пост. объёме и хим. потенциала получим:

$$E = 3NkT/2, \quad c_V = 3k/2,$$

$$\mu = kT \ln \{ [2\pi\hbar^2/mkT]^{3/2} N/gV \}.$$

Характерно, что даже для невырожденного (т. е. с достаточной точностью подчиняющегося классич. механике) газа выражения для свободной энергии и хим. потенциала содержат постоянную Планка \hbar . Это обусловлено отмеченной ранее связью энтропии с количеством числа квантовых состояний.

В случае двухатомных и многоатомных газов вклад в термодинамик. ф-ции вносят также колебания и вращение молекул.

Неидеальный газ. Важное достижение С. ф. — вычисление поправок к термодинамик. величинам газа, связанных с взаимодействием между его частицами. С этой точки зрения *уравнение состояния* идеального газа является первым членом разложения давления реального газа по степеням плотности числа частиц, поскольку всякий газ при достаточно малой плотности ведёт себя как идеальный. С повышением плотности начинают играть роль поправки к ур-нию состояния, связанные с взаимодействием, так что давление описывается *виртуальным разложением*:

$$P = (NkT/V) [1 + B(T)N/V + C(T)(N/V)^2 + \dots]. \quad (14)$$

Для нахождения второго в и р и а л а з н о г о к о э ф ф и ц и е н т а $B(T)$ одноатомного газа достаточно считать, что в газе одновременно взаимодействуют только два атома. Задача сводится в таком случае к вычислению статистич. суммы двух атомов с энергией взаимодействия $u(r)$, в результате

$$B(T) = 2\pi \int_0^\infty [1 - \exp(-u(r)/kT)] r^2 dr. \quad (15)$$

По порядку величины B равен r_0^2 , где r_0 — характерный размер атома, или, точнее, радиус действия меж-

атомных сил. Это означает, что ряд (14) фактически представляет собой разложение по степеням безразмерного газового параметра $\eta = r_s^3 N/V$.

Плазма. Особый случай неидеального газа представляет собой плазма — частично или полностью ионизов. газ, в к-ром имеются свободные электроны и ионы. При вычислении поправок к термодинамич. ф-циям плазмы существенно, что электроны и ионы взаимодействуют электростатически (по закону Кулона). Кулоновские силы медленно убывают с расстоянием, поэтому интеграл во втором вириальном коэф. ф-лы (15) расходитс. на больших расстояниях r между частицами. В действительности под влиянием кулоновских сил распределение ионов и электронов в плазме изменяется т. о., что поле каждой частицы экранируется, т. е. быстро убывает на расстояния, называемое *дебиевским радиусом экранирования* и равном по порядку величин

$$r_D \sim (kTV/e^2N)^{1/2},$$

где N — число электронов, e — заряд электрона. Все частицы, находящиеся внутри сферы дебиевского радиуса, одновременно принимают участие во взаимодействии, поэтому первая поправка к давлению пропорциональна не $(N/V)^2$, как в обычном газе, а более низкой степени плотности $(N/V)^{3/2}$. Количеств. расчёт основан на том, что частицы распределены в поле выбранного электрона (или иона) согласно распределению Больцмана. В результате ур-ние состояния имеет вид:

$$P = 2NkT/V - (e^2/3)(\pi/kT)^{3/2}(2N/V)^{3/2},$$

если в плазме имеются только одновалентные ионы. Такого же рода поправки возникают и в термодинамич. ф-циях з л е к т р о л и т о в, в к-рых имеются свободные ионы растворённых веществ.

Жидкости. В отличие от газа, для жидкости связанные с взаимодействием члены в ур-нии состояния не малы. Поэтому свойства жидкости сильно зависят от конкретного характера взаимодействия между её молекулами. В теории жидкости вообще отсутствует малый параметр, к-рый можно было бы использовать для упрощения теории. Невозможно получить к-л. аналитич. ф-лы для термодинамич. величин жидкости. Одним из способов преодоления этой трудности является изучение системы, состоящей из сравнительно небольшого числа частиц (~к-л. тысяч). В этом случае, используя ЭВМ, можно провести прямое решение ур-ний движения частиц и определить таким способом ср. значения всех характеризующих систему величин без доп. предположений (см. *Молекулярной динамики метод*). Удаётся исследовать и процесс приближения такой системы к состоянию равновесия. Можно также найти статистич. интеграл для такой системы из небольшого числа частиц, вычислив на ЭВМ соответствующие интегралы (обычно при этом используют *Монте-Карло метод*). Полученные этими способами результаты имеют, однако, малую точность в приложении к реальным жидкостям из-за малого числа частиц в системе.

Ещё один способ построения теории жидкости основан на использовании ур-ния (12), связанного двух- и трёхчастичные ф-ции распределения. В теории жидкости это точное соотношение дополняют иск-рым приближёнными ф-лами, выражающими трёхчастичную ф-цию через двухчастичную. В результате получают ур-ние для двухчастичной ф-ции, к-рое решают численно. Дополнит. соотношения находят на основании правдоподобных физ. соображений, они носят интеграл. характер, так что основанные на них теории могут претендовать лишь на ограниченную точность. Тем не менее даже такое описание имеет важное значение, поскольку в нём проявляется общность законов С. ф. (см. также *Жидкость, Гиперцепное уравнение, Перкуса — Йеоска уравнение*).

Вырожденные газы. Если понижать темп-ру газа при пост. плотности, начинают проявляться квантосомаинч. эффекты, связанные со свойствами симметрии волновых ф-ций системы тождественных частиц, т. е. газ вырождается. Это вырождение наступает при темп-рах, когда длина волны де Бройля для частиц, движущихся с тепловой скоростью, становится порядка ср. расстояния между ними (см. *Квантовый газ*).

Для частиц с полужелым спином волновая ф-ция должна менять знак при перестановке любой пары частиц, поэтому в одном квантовом состоянии не может находиться больше одной частицы (*Паули принцип*). Кол-во частиц с целым спином в одном состоянии может быть любым, но требуемая в этом случае неизменность волновой ф-ции при перестановке частиц и здесь приводит к изменению статистич. свойств газа. Частицы с полужелым спином описываются *Ферми — Дирака статистикой*, их называют фермионами. К фермионам относятся, напр., электроны, протоны, нейтроны, атомы дейтерия, атомы ^3He . Частицы с целым спином (бозоны) описываются *Бозе — Эйнштейна статистикой*. К ним относятся, напр., атомы H , ^4He , кванты света — фотоны.

Пусть ср. число частиц газа в единице объёма с импульсами, лежащими в интервале dp , есть $n_p dp/dh^3$, так что n_p — число частиц в одной ячейке фазового пространства. Тогда из распределения Гиббса следует, что для идеальных газов фермионов (верхний знак) и бозонов (нижний знак)

$$n_p = \{\exp\{[-\mu - \epsilon_p]/kT\} \pm 1\}^{-1}. \quad (16)$$

В этой ф-ле $\epsilon = p^2/2m$ — энергия частицы с импульсом p , μ — хим. потенциал, определяемый из условия постоянства числа частиц N в системе:

$$h^{-3} \int n_p dp = N/V.$$

Ф-ла (16) переходит в ф-лу распределения Больцмана (13) при $T \gg (N/V)^{1/3} h^2/mk$; величина справа наз. темп-рой вырождения.

В случае фермионов, как и должно быть, $n_p \leq 1$, поэтому частицы ферми-газа и при $T = 0$ обладают отличными от нуля импульсами, поскольку в состоянии с нулевым импульсом может находиться только одна частица. Точнее, при $T = 0$ для ферми-газа $n_p = 1$ внутри *ферми-поверхности* — сферы в импульсном пространстве с радиусом $p_0 = \hbar(6\pi^2 N/V)^{1/3}$; вне этой сферы $n_p = 0$. При конечных, но низких темп-рах n_p меняется от 1 внутри сферы до нуля вне сферы постепенно, причём ширина переходной области $\sim mkT/p_0$. Величина n_p для ферми-газа как ф-ция от энергии ϵ изображена схематически на рис. 1 ($\epsilon_0 = p_0^2/2m$). При изменении

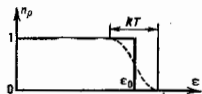


Рис. 1. Функция распределения Ферми — Дирака.

темп-ры газа меняется состояние частиц только в этом переходном слое, поэтому теплоёмкость ферми-газа при низких темп-рах пропорциональна T и равна: $c = (g\hbar^3/6V)^{1/3} mkT/k^2$.

В бозе-газе при $T = 0$ все частицы находятся в состоянии с нулевым импульсом. При достаточно низких темп-рах в состоянии $p = 0$ находится конечная доля всех частиц; эти частицы образуют т. н. бозе-эйнштейновский конденсат. Остальные частицы находятся в состоянии $p \neq 0$, причём их число определяется ф-лой (16) с $\mu = 0$. При темп-ре $T_c = (N/V)^{1/3} 3Z\hbar^2/mk$ в бозе-газе происходит *фазовый переход*. Доля частиц с нулевым импульсом обращается в нуль, *Бозе — Эйнштейна конденсация* исчезает. Схематически ф-ции

распределения Максвелла, Ферми — Дирака и Бозе — Эйнштейна (при $T > T_c$) изображены на рис. 2.

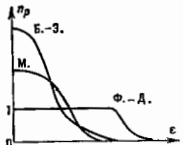


Рис. 2. Сравнение функций распределения: Максвелла (М.), Ферми — Дирака (Ф.-Д.), Бозе — Эйнштейна (Б.-Э.).

Особым случаем применения статистики Бозе — Эйнштейна является равновесное эл.-магн. излучение, к-рое можно рассматривать как газ, состоящий из фотонов. Энергия фотона связана с его импульсом соотношением $\epsilon = pc$, где c — скорость света в вакууме. Число фотонов не является заданной величиной, а само определяется из условия термодинамич. равновесия, поэтому их распределение по импульсам даётся ф-лой (16) с $\mu = 0$ (причём $\epsilon = pc$). Т. о. получается ф-ла Планка для спектра равновесного (чёрного) излучения (см. *Планка закон излучения*).

Кванзапчасти. Вблизи абс. нуля темп-ры гл. вклад в статист. сумму вносят слабообужденные квантовые состояния, близкие по энергии к основному. Вычисление энергии осн. состояния является чисто квантовомеханич. задачей, предметом *квантовой теории многих частиц*. Тепловое движение в таких условиях можно описать как появление в системе слабо-взаимодействующих *кванзапчастиц* (элементарных возбуждений), обладающих энергией ϵ и импульсом (в кристаллах — квазиимпульсом) p . Зная зависимость $\epsilon(p)$, можно вычислить зависящую от темп-ры часть термодинамич. ф-ций по ф-лам для идеального ферми-ида бозе-газа в зависимости от статистики кванзапчасти. Особенно важно, что бозевские кванзапчасти с малыми p можно рассматривать как кванты длинноволновых колебаний, описываемых макроскопич. ур-ниями. Так, в кристаллах (и бозе-жидкостях) существуют фононы (кванты звука), в магнетиках — магныны (кванты колебаний магн. момента).

Особые типы кванзапчастиц существуют в двумерных и одномерных системах. В плоской кристаллич. плёнке их роль играют дислокации, в плёнках Не — вихревые нити, в полимерных нитях — солитоны и доменные стенки. В трёхмерных телах эти объекты имеют большую энергию и не вносят вклада в термодинамич. ф-ции.

Неидеальные выроджденные газы. Исследование свойств таких газов при условии малости газового параметра η представляет осн. интерес. В ферминовском газе поправка к энергии осн. состояния оказывается $\sim \eta^{1/2}$. Спектр кванзапчасти в случае газа с отталкиваемым межд. частицами совпадает (с точностью до поправки $\sim \eta^{1/2}$) со спектром свободных частиц. В спектре газа с притяжением между частицами возникает экспоненциально малая (по параметру $\eta^{1/2}$) доля, что связано со *сверхтекучестью* (см. также *Сверхпроводимость*), и появляется фононная ветвь. Энергия осн. состояния, равная нулю у идеального бозе-газа, составляет $\sim (N/V)^{1/3} \eta^{1/2} N \mu^2 / m$ для неидеального. Спектр кванзапчасти при малых η является фононным, а при больших η переходит в спектр свободных частиц (см. также *Квантовая жидкость*).

Кристаллическая решётка. Атомы в решётке совершают малые колебания около своих положений равновесия. Это означает, что их тепловое движение можно рассматривать как совокупность кванзапчастиц (фононов) при всех (а не только низких) темп-рах (см. *Колебания кристаллической решётки*). Распределение фононов, как и фотонов, даётся ф-лой (16) с $\mu = 0$. При низких темп-рах существуют лишь длинноволновые

фононы, к-рые представляют собой кванты звуковых волн, описываемых ур-ниями теории упругости. Зависимость $\epsilon(p)$ для них линейна, поэтому теплоёмкость кристаллич. решётки пропорциональна T^3 . При высоких темп-рах можно пользоваться законом равномерного распределения энергии по степеням свободы, так что теплоёмкость не зависит от темп-ры и равна $3Nk$, где N — число атомов в кристалле. Зависимость $\epsilon(p)$ при произвольных p можно определить из опытов по неупругому рассеянию нейтронов в кристалле или вычислить теоретически, задавая значения «силовых констант», определяющих взаимодействие атомов в решётках. Новые проблемы встали перед С. ф. в связи с открытием т. н. квазиупорядоч. кристаллов, молекулы к-рых расположены в пространстве неупорядоченно, но в нек-ром порядке (см. *Квазикристаллы*).

Металлы. В металлах вклад в термодинамич. ф-ции дают также электроны проводимости. Состояние электрона в металле характеризуется квазиимпульсом, и т. к. электроны подчиняются статистике Ферми — Дирака, их распределение по квазиимпульсам даётся ф-лой (16). Поэтому теплоёмкость электронного газа, а следовательно, и всего металла при достаточно низких темп-рах пропорциональна T . Отличие от ферми-газа свободных частиц состоит в том, что ферми-поверхности уже не является сферой, а представляет собой нек-рую сложную поверхность в пространстве квазиимпульсов. Форму поверхности Ферми, равно как и зависимость энергии от квазиимпульса вблизи этой поверхности, можно определять экспериментально, гл. обр. исследуя магн. свойства металлов, а также рассчитывая теоретически, используя т. н. модель сферического потенциала. В сверхпроводниках возбуждённые состояния электрона отделены от ферми-поверхности щелью, что приводит к экспоненц. зависимости антиферромагн. теплоёмкости от темп-ры. В ферромагн. и антиферромагн. веществах вклад в термодинамич. ф-ции дают также колебания магн. моментов (спиновые волны).

В диэлектриках и полупроводниках при $T = 0$ свободные электроны отсутствуют. При конечных темп-рах в них появляются заряд. кванзапчасти: электроны с отриц. зарядом и «дырки» с положит. зарядом. Электрон и дырка могут образовать связанное состояние — кванзапчастицу, называемую *экситоном*. Др. тип экситона представляет собой возбуждённое состояние атома диэлектрика, перемещающееся в кристаллич. решётке.

Методы квантовой теории поля в статистической физике. При решении задач квантовой С. ф., прежде всего при исследовании свойств квантовых жидкостей, электронов в металлах и магнетиках, важное значение имеют методы квантовой теории поля, введённые в С. ф. сравнительно недавно. Осн. роль в этих методах играет *Грина функция* макроскопич. системы, аналогичная ф-ции Грина в квантовой теории поля. Она зависит от энергии ϵ и импульса p , закон дисперсии кванзапчасти $\epsilon(p)$ определяется из ур-ния $[(G, p)]^{-1} = 0$, т. к. энергия кванзапчасти является лосомом ф-ции Грина. Существует регулярный метод вычисления ф-ции Грина в виде ряда по степеням энергии взаимодействия между частицами. Каждый член этого ряда содержит многократные интегралы по энергиям и импульсам от ф-ции Грина независимых частиц и может быть изображён графически в виде диаграмм, аналогичных *Фейнман диаграммам* в квантовой электродинамике. Каждая из этих диаграмм имеет определ. физ. смысл, что позволяет отделить в бесконечном ряду члены, ответственные за интересное явление, и просуммировать их. Существует также диаграммная техника для вычисления температурных ф-ции Грина, позволяющая находить термодинамич. величины непосредственно, без введения кванзапчастиц. В этой технике гравископич. ф-ции задаются (вместо энергии) от нек-рых дискретных частот ω_n и интегралы по энергиям заменяются на сумму по этим частотам.

Фазовые переходы. При непрерывном изменении веш. параметров (напр., давления или темп-ры) свойства системы могут при нек-рых значениях параметров измениться скачкообразно, т. е. происходит фазовый переход. Фазовые переходы делятся на переходы 1-го рода, сопровождающиеся выделением скрытой теплоты перехода и скачкообразным изменением объема (напр., плавление), и переходы 2-го рода, в к-рых скрытая теплота и скачок объема отсутствуют, а имеется скачок теплоемкости (напр., переход в сверхпроводящее состояние). При переходе 2-го рода меняются симметрия тела. Это изменение коллективно характеризуется *параметром порядка*, отличным от нуля в одной из фаз и обращающимся в нуль в точке перехода. Статистич. теория фазовых переходов составляет важную, но ещё далёкую от завершения область С. ф. Наиб. трудность для теоретич. исследования представляют при этом свойства вещества вблизи *критической точки* фазового перехода 1-го рода и в непосредств. близости линии фазового перехода 2-го рода. (На нек-ром расстоянии от этой линии переход 2-го рода описывается *Ландау теорией*.) Здесь аномально возрастают флуктуации, и рассмотренные выше приближённые методы С. ф. неприменимы. Поэтому важную роль играют *точно решаемые модели*, в к-рых есть переходы (см. *Двумерные решёточные модели*). Сущность продвижение в построении флуктуац. теории фазовых переходов достигнуто методом *эпсилон-разложения*. В нём переход исследуется в воображаемом пространстве с числом измерений $(4 - \epsilon)$, а результаты экстраполируются к $\epsilon = 1$, т. е. реальному пространству трёх измерений. В двумерных системах возможны своеобразные фазовые переходы, когда при нек-рой темп-ре появляются дислокации или вихревые пары. Параметр порядка в точке перехода обращается в нуль скачком, а теплоёмкость непрерывна.

Неупорядоченные системы. Своёобразное место в С. ф. занимают *стёкла* — твёрдые тела, атомы к-рых расположены беспорядочно даже при абс. нуле темп-р. Строго говоря, такое состояние является неравновесным, но с чрезвычайно большим временем релаксации, так что неравновесность фактически не проявляется. Теплоёмкость стёкол при низких темп-рах линейно зависит от T . Это следует из выражения для Z в виде (8). При $T \rightarrow 0$ зависимость от T определяется поведением $g(E)$ при малых E . Но для *неупорядоченных систем* значение $E = 0$ ничем не выделено, так что $g(0)$ конечно, $Z = A + g(0)T$ и $c \sim T$. Интересной особенностью стёкол является зависимость наблюдаемых значений теплоёмкости от времени измерения. Это объясняется тем, что уровни энергии с малыми E связаны с квантовым туннелированием атомов через высокий потенциальный барьер, требующий большого времени. Интересны свойства *спиновых стёкол* — систем беспорядочно расположенных атомов, имеющих магн. моменты.

Статистическая физика неравновесных процессов. Всё большее значение приобретает *кинетика физической* — раздел С. ф., в к-ром изучают процессы в системах, находящихся в неравновесных состояниях. Здесь возможны две постановки вопроса: можно рассмотреть систему в нек-ром неравновесном состоянии и следить за её переходом в состояние равновесия; можно рассматривать систему, неравновесное состояние к-рой поддерживается ввн. условиями, напр. тель, в к-ром задан градиент темп-ры, протекает электр. ток и т. п., или тела, находящиеся в перем. ввн. поле.

Если отклонение от равновесия мало, неравновесные свойства системы описываются т. н. *кинетическими коэффициентами*. Примерами таких коэф. являются коэф. вязкости, теплопроводности и диффузии, электропроводности металлов и т. п. Эти величины удовлетворяют принципу симметрии кинетич. коэффициентов, выражающему симметрию ур-ний механики относительно изменения знака времени (см. *Онсагера теорема*).

Более общим понятием является *обобщённая восприимчивость*, описывающая изменение бж ср. значения нек-рой физ. величины x под действием малой обобщённой силы f , к-рая входит в гамильтониан системы в виде $-fx$, где \hat{x} — квантовомеханич. оператор, соответствующий x . Если f зависит от времени как $\exp(-i\omega t)$, изменение бж можно записать в виде $\delta x = \alpha(\omega)f$. Комплексная величина $\alpha(\omega)$ и есть обобщённая восприимчивость, она описывает поведение системы по отношению к ввн. воздействию. С др. стороны, она определяет и релаксацион. свойства: при $t \rightarrow \infty$ величина α релаксирует к своему равновесному значению по закону $\exp(-\gamma t)$, где γ — расстояние от вещественной оси до ближайшей к ней особенности ф-ции $\alpha(\omega)$ в нижней полуплоскости комплексной переменной ω . К числу задач С. ф. неравновесных процессов относится и исследование зависимости флуктуаций от времени. Эта зависимость описывается временной корреляц. ф-цией $\phi(t)$, в к-рой усредняются флуктуации величины x , взятые в разл. моменты времени t :

$$\phi(t_1 - t_2) = \overline{\Delta x(t_1) \Delta x(t_2)},$$

$\phi(t)$ является чётной ф-цией воего аргумента. В классической С. ф. существует связь между $\phi(t)$ и законом релаксации величины x . Если релаксация описывается нек-рым линейным дифференц. ур-нием для отклонения \bar{x} от равновесного значения, то тому же ур-нию удовлетворяет и $\phi(t)$ при $t > 0$.

Соотношение между $\phi(t)$ и $\alpha(\omega)$ устанавливает *флуктуационно-диссипативная теорема*. Теорема утверждает, что фурье-образ корреляц. ф-ции

$$\Phi_{\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \exp(i\omega t) dt$$

выражается через $\alpha(\omega)$ следующим образом:

$$\Phi_{\omega} = \hbar \operatorname{cth}(\hbar\omega/2kT) \operatorname{Im} \alpha(\omega). \quad (17)$$

Частным случаем (17) является *Найквиста формула*. Описание сильно неравновесных состояний, а также вычисление кинетич. коэф. производится с помощью *кинетического уравнения Больцмана*. Это ур-ние представляет собой интегрированный дифференц. ур-ние для одночастичной ф-ции распределения (в квантовом случае — для одночастичной матрицы плотности, или статистич. оператора). Оно содержит члены двух типов. Один описывает изменение ф-ции распределения при движении частиц во ввн. полях, другие — при столкновениях частиц. Именно столкновения приводят к возрастанию энтропии неравновесной системы, т. е. к релаксации. Замкнутое, т. е. не содержащее др. величин кинетич. ур-ние, невозможно получить в общем виде. При его выводе необходимо использовать малые параметры, имеющиеся в данной конкретной задаче. Важнейшим примером является кинетич. ур-ние, описывающее установление равновесия в газе за счёт столкновений между молекулами. Оно справедливо для достаточно разреженных газов, когда длина свободного пробега велика по сравнению с расстояниями между молекулами. Конкретный вид этого ур-ния зависит от эфф. сечения рассеяния молекул друг на друге. Если это сечение известно, ур-ние можно решать, разлагая искомую ф-цию по ортогональным полиномам. Таким способом можно вычислить кинетич. коэф. газа, исходя из известных законов взаимодействия между молекулами. Кинетич. ур-ние учитывает только парные столкновения между молекулами и описывает только первый ввнечасящий член разложения этих коэф. по плотности газа. Удалось найти и более точное ур-ние, учитывающее также тройные столкновения, что позволило вычислить следующий член разложения.

Общую проблему представляет вывод кинетики ур-ния для плазмы. Из-за медленного убывания кулоновских сил с расстоянием даже при рассмотрении парных столкновений существенно акранирование этих сил остальными частицами. Неравновесные состояния твердых тел и квантовых жидкостей можно при близких темп-рах рассматривать как неравновесные состояния газа соответствующих кваичастиц. Поэтому кинетику процессы в таких системах описываются кинетику ур-ниями для кваичастиц, учитывающими столкновения между ними и процессы их взаимного превращения. Новые возможности открыло применение в физ. кинетике методов квантовой теории поля. Кинетику коэф. системы можно выразить через её ф-цию Грина, для к-рой существует общий способ вычисления с помощью диаграмм. Это позволяет в ряде случаев получить кинетику коэф. без явного использования кинетику ур-ния и исследовать неравновесные свойства системы даже в тех случаях, когда не выполняются условия его применимости.

Основные вехи развития статистической физики. С. ф. целиком основана на представлениях об атомном строении материи. Повторю нач. период развития С. ф. совпадает с развитием атомистич. представлений. Развитие С. ф. как раздела теоретич. физики началось в сер. 19 в. В 1859 Дж. Максвелл (J. Maxwell) определил ф-цию распределения молекул газа по скоростям. В 1860–70 Р. Клаузиус (R. Clausius) ввел понятие длины свободного пробега и связал её с вязкостью и теплопроводностью газа. Примерно в то же время Л. Больцман (L. Boltzmann) обобщил распределение Максвелла на случай, когда газ находится во внеш. поле, доказал теорему о равномерном распределении энергии по степеням свободы, вывел кинетику ур-ние, дал статистич. истолкование энтропии и показал, что закон её возрастания является следствием кинетику ур-ния. Построение классической С. ф. было завершено к 1902 в работах Дж. У. Гиббса (J. W. Gibbs). Теория флукуатаций была разработана в 1905–06 в работах М. Смолуховского (M. Smoluchowski) и А. Эйнштейна (A. Einstein). В 1900 М. Планк (M. Planck) вывел закон распределения энергии в спектре излучения чёрного тела, положив начало развитию как квантовой механики, так и квантовой С. ф. В 1924 Ш. Боэе (Sh. Bose) нашёл распределение по импульсам световых квантов и связал его с распределением Планка. Эйнштейн обобщил распределение Боэе на газы с заданным числом частиц. Э. Ферми (E. Fermi) в 1925 получил ф-цию распределения частиц, подчиняющихся принципу Паули, а П. А. М. Дирак (P. A. M. Dirac) установил связь этого распределения и распределения Боэе — Эйнштейна с матем. аппаратом квантовой механики. Дальнейшее развитие С. ф. в 20 в. шло под знаком приложения её осн. принципов к исследованию коэрентных процессов.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., *Статистическая физика*, ч. 1, 3 изд., М., 1976; Майер Дж., Гепберт М. Яер С., *Статистическая механика*, пер. с англ., 2 изд., М., 1940; Абрикосов А. А., Горюнов Л. П., Давыдов Ю. И. Е., *Методы квантовой теории поля в статистической физике*, М., 1962; Хуанг К., *Статистическая механика*, пер. с англ., М., 1966; Киртле Г. Я., *Квантовая теория твёрдых тел*, пер. с статистической физики, М., 1973; Гиббс Дж. У., *Методы статистической физики*, М., 1979; Вальеску Р., *Равновесная и неравновесная статистическая механика*, пер. с англ., т. 1—2, М., 1978; Боголюбов Н. Н., *Избранные труды по статистической физике*, М., 1979; Гиббс Дж. У., *Термодинамика. Статистическая механика*, пер. с англ., М., 1982; Леонов О. Я. М. А., *Введение в термодинамику. Статистическая физика*, М., 1983; Вольфганг Л. П., *Избранные труды*, пер. с нем., франц., М., 1983.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ — совокупность очень большого (в пределе бесконечного) числа одинаковых физ. систем мн. частиц («юний» данной системы), находящихся в одинаковых макроскопич. состояниях. При этом макроскопич. состояния систем, сос-

тавляющих С. а., могут различаться, но совокупности их должна отвечать заданным значениям макроскопич. параметров с точностью до пренебрежимо малых флукуатаций. С. а. — одно из осн. понятий *статистической физики*, оно позволяет применять методы теории вероятностей для решения физ. задач, напр. для вычисления термодинамич. ф-ций. С. а. описывается *функциями распределения* частиц по координатам и импульсам в случае классич. механики или статистич. операторами (*матрицами плотности*) в случае квантовой механики.

Примеры С. а.: энергетически малопрованные системы частиц при заданной полной энергии (микроравновес. ансамбль), системы частиц в контакте с термостатом заданной темп-ры (канонич. ансамбль), системы частиц в контакте с термостатом и резервуаром частиц (большой канонич. ансамбль). Идея С. а. применима также к неравновесным системам. В этом случае макроскопич. состояние можно описывать пространственно неоднородными и зависящими от времени параметрами (см. *Грина — Кубо формул.*)

Д. Н. Зубарев

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЕС. 1) С. в. в *квантовой механике* — кратность вырождения уровня энергии. 2) С. в. в *термодинамике и статистической физике* — число способов, к-рыми может быть реализовано данное макроскопич. состояние системы. Термодинамически равновесное макроскопич. состояние системы характеризуется определ. значениями полной энергии \mathcal{E} , полного числа частиц N и объёма системы. Микроскопич. состояние системы соответствует заданному распределению её частиц по возможным классич. или квантовым состояниям. С. в. \mathcal{E} равен числу микроскопич. состояний, реализующих данное макроскопич. состояние, поэтому $\mathcal{E} \geq 1$. Иногда С. в. наз. термодинамической вероятностью.

В случае непрерывного спектра энергии под С. в. понимают число квантовых состояний в данном интервале значений энергии. При переходе от канонической к классич. теории (и наоборот, приближенно) устанавливается связь между \mathcal{E} и величиной фазового объёма системы, соответствующего данному интервалу энергии. С. в. наз. величиной фазового объёма в единицах h^3 , где h — число степеней свободы данной системы. Величине h^3 соответствует мнж. фазовый объём для системы с одной степенью свободы в кваизначасеч. приближении. Аналитически С. в. можно найти лишь для модельных систем, для реальных систем его можно оценить по величине *статистической суммы*.

С. в. связан с *энтропией* S системы соотношением Больцмана $S = k \ln \mathcal{E}$. При фиксированных значениях \mathcal{E} и N С. в. имеет макс. величину для равновесного состояния. При расчёте С. в. существенно, считаются ли одинаковые частицы различимыми или нет, поэтому в квантовой и классич. теориях получаются разл. значения С. в. Из условия максимума С. в. впервые были получены квантовые распределения Ферми — Дирака и Боэе — Эйнштейна.

Д. Н. Зубарев

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ — величина, образная нормирующей множителем в *каноническом распределении Гиббса* в статистич. физике, классич. систем и равная интегралу по всем фазовым переменным p, q системы:

$$Z = (N! h^{3N})^{-1} \int dpdq \exp[-H(p, q)/kT],$$

где $H(p, q)$ — *Гамильтона функция* системы, N — число частиц, T — *абс. темп-ра*. Для системы N частиц (без внутр. степеней свободы), взаимодействующих с парным потенциалом $\Phi(|q_i - q_j|)$, ф-ция Гамильтона (полная энергия как ф-ция координат и импульсов всех частиц)

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^N p_i^2 / 2m + \sum_{i < j} \Phi(|q_i - q_j|),$$

$dpdq = dp_1 dq_1 \dots dp_N dq_N$ — элемент объема фазового пространства, множитель $1/N!$ связан с тождественностью частиц, множитель h^{-3N} связан с тем, что нам. размер ячейки в фазовом пространстве равен h , если рассмотреть С. и. как предел *статистической суммы* при переходе от квантовой механики к классической. С. и. нап. также интегриралом состояний.

С. и. связан со свободной энергией системы (Гельмгольца *энергия*) соотношением $F = -kT \ln Z$, к-рое является одним из основных в статист. физике, т. к. позволяет вычислить F как ф-цию темп-ры, объема и числа частиц в зависимости от закона взаимодействия между частями, а следовательно вычислить и др. *потенциалы термодинамические*.

Интегрирование по импульсам в С. и. легко выполняется, в результате С. и. сводится к конфигурационному интегралу по $3N$ координатам:

$$Z = (V^N / N! \Lambda^{3N}) \int dq \exp \left\{ - \sum_{\langle i, j \rangle} \Phi(|q_i - q_j|) / kT \right\},$$

где $\Lambda = h(2\pi mkT)^{-1/2}$ — длина волны де Бройля, соответствующая энергии kT . Для идеального газа $Z = V^N / N! \Lambda^{3N}$. В квантовой механике координаты и импульсы являются некоммутирующими операторами и подобное упрощение статист. суммы невозможно. Вычисление С. и. — одна из осн. задач статист. физики классич. систем (см., напр., *Вирхальное разложение*).

Лит.: Майер Дж., Гейсерт-Майер М., *Статистическая механика*, пер. с англ., 2 изд., М., 1980, гл. 8; Х и я т. Статистическая механика, пер. с англ., М., 1960, гл. 5; Де о н т о в и ч М. А., *Введение в термодинамику*, Статистическая физика, М., 1983. Д. Н. Зубарев.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ — определяющие правила, согласно к-рым по результатам наблюдений принимается решение в задаче *статистической проверки гипотез*. С. к. строится следующим образом. Выбирается проверочная статистика $X(x|H_0)$ — ф-ция данных наблюдений x и проверяемой гипотезы H_0 . Пространство Ω всех возможных значений X разбивается на две области — критическую ω и допустимую ω_0 . Если реализовавшееся в эксперименте значение проверочной статистики X попадает в критич. область ω , то гипотеза H_0 отвергается, в противном случае гипотеза H_0 считается непротиворечивой результатом эксперимента и принимается. Размер критич. области ω выбирается таким, чтобы вероятность отвергнуть гипотезу, когда она верна, т. е. величина $\alpha = P(X \in \omega | H_0)$, была бы малой. Величину α наз. уровнем значимости данного критерия или ошибкой 1-го рода.

В тех случаях, когда есть только одна гипотеза H_0 , т. е. стоит задача подтверждения или опровержения H_0 , используемые критерии наз. критериями согласия. Для данных, сгруппированных в *гистограмму*, наиб. популярными являются следующие два критерия. χ^2 — критерий Пирсона. Как известно, ф-ция плотности вероятности *мультиномиального распределения*, к-рому подчиняются числа событий в бинах (каналах) гистограммы, в асимптотике по числу событий сходится к ф-ции плотности вероятности нормального распределения. Это позволяет показать, что статистика

$$X(x|H_0) = \sum_{i=1}^k (n_i - Np_i)^2 / Np_i, \quad (1)$$

где n_i — число событий в i -м бине гистограммы, k — число бинов, N — полное число событий, p_i — вероятность попадания события в i -й бин, согласно гипотезе H_0 , распределена по χ^2 -распределению с $k - 1$ степенями свободы. Выбирая (1) в качестве проверочной статистики и критич. область $X_c \leq X < \infty$, получаем χ^2 -критерий Пирсона с уровнем значимости

$$\alpha = \int_{X_c}^{\infty} dx P_x(x|X).$$

Критерий серий использует информацию о знаках разностей $n_i - Np_i$, и-рая теряется в χ^2 -критерии. Если гипотеза H_0 полностью определена (простая гипотеза), то критерий серий не зависит от χ^2 -критерия для той же самой гистограммы и нест. независимую дополнит. информацию. Назовем *серией* последовательность отклонений $n_i - Np_i$ от нуля. Если гипотеза H_0 верна, то оба вида знаков отклонений равновероятны. Это позволяет вычислить распределение вероятности для числа серий R . Выбирая в качестве проверочной статистики величину R и в качестве критич. области $R \leq R_c$, при $P(R \leq R_c) = \alpha$, получим критерий серий с уровнем значимости α .

Боле офф. критериями проверки гипотез H_0 являются критерии, предложенные Н. В. Смирновым и А. Н. Колмогоровым. Они используются в качестве проверочных статистик разл. *расстояний* между экспериментальной (выборочной) ф-цией распределения

$$F_N(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ n/N, & x_1 \leq x < x_{n-1} \\ 1, & x \geq x_n \end{cases}$$

и ф-цией распределения $F_0(x)$, отвечающей гипотезе H_0 . Критерий Смирнова — Крамера — Мизеса в качестве проверочной статистики использует ф-цию

$$NW^2 = N \int dx [F_N(x) - F_0(x)]^2(x),$$

где $\int(x)$ — плотность ф-ции распределения $F_0(x)$. Н. В. Смирновым вычислена плотность распределения вероятности величины NW^2 в асимптотич. пределе $N \rightarrow \infty$. Критерий Колмогорова использует в качестве проверочной статистики ф-цию

$$\sqrt{N} D_N = \sqrt{N} \max |F_N(x) - F_0(x)|,$$

асимптотич. распределение к-рой было получено Колмогоровым. Численные значения ф-ций распределения NW^2 и $\sqrt{N} D_N$ можно найти в [1]. Др. критерии проверки гипотез H_0 можно найти в [1—3].

Пусть теперь кроме гипотезы H_0 есть альтернативная простая гипотеза H_1 и стоит задача выбора одной из них на основании вектора измерений x . В этом случае вводятся величина, называемая мощностью критерия, к-рая определяется как вероятность $1 - \beta$ попадания X в критич. область ω , когда верна гипотеза H_1 , т. е. $1 - \beta = P(X \in \omega | H_1)$. Мощность прямо связана с вероятностью принятия ложной гипотезы (ошибка 2-го рода): $\beta = P(X \in \omega_0 | H_1)$. Мощность позволяет сравнивать критерии между собой: наилучшим критерием для сравнения H_0 и H_1 с данным уровнем значимости α служит критерий с макс. мощностью. Задачу поиска наиб. мощного критерия можно свести к задаче нахождения наилучшей критич. области в X -пространстве. Решением последней задачи является критерий Неймана — Пирсона:

если $l_N(x|H_0, H_1) > C_\alpha$, то принимается H_1 ; если $l_N(x|H_0, H_1) \leq C_\alpha$, то принимается H_0 . Здесь $l_N(x|H_0, H_1) = f_N(x|H_1) / f_N(x|H_0)$ — отношение правдоподобия, $f_N(x|H_i)$ — ф-ция плотности вероятности x , если справедлива гипотеза H_i , а C_α выбрано таким образом, чтобы выполнялось условие $\int dx f_N(x|H_0) = \alpha$.

Область ω состоит из тех точек пространства Ω , в к-рых $l_N(x|H_0, H_1)$ принимает наиб. значения.

Критерий наз. состоятельным, если $\lim_{N \rightarrow \infty} P(x \in \omega | H_1) = 1$, т. е. если критерий с ростом числа наблюдений всё

лучше разделяет гипотезы. Критерий наз. несмещённым, если для любой альтернативной гипотезы H_1 критич. область выража та, что $P(x \in (H_1)) \geq \alpha$.

Если гипотеза H_0 или H_1 (или обе) не являются полностью определёнными (словные гипотезы), то не существует оптим. метода конструирования наилучшего критерия. На практике в качестве проверочной статистики обычно используется отношение максимуму правдоподобия [2].

Лит.: 1) Болдышев Л. Н., Смирнов Н. В., Таблицы математической статистики, 3 выд., М., 1983; 2) Статистические методы в экспериментальной физике, пер. с англ., М., 1978; 3) Кендалл М., Стьюарт А., Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973.

В. П. Жуков, С. В. Кашченко.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР (матрица плотности) — оператор, с помощью которого можно вычислить ср. значение любой физ. величины в квантовой механике и квантовой статистич. физике. С. о. описывает состояние системы, не основанное на полном (в смысле квантовой механики) наборе данных о системе (смешанное состояние). Подробнее см. *Матрица плотности*.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ — один из осн. разделов матем. статистики, посвящённый оцениванию параметров теоретич. моделей по косвенным измерениям или распределений случайной величины x по наблюдению её реализации. Если предполагается, что распределение является элементом параметр. семейства $p(x|a)$, то возникает задача параметрич. ског о оценки a в x . Когда вид распределения неизвестен, говорят о задаче не параметрич. ског о оценки a в x . При параметрич. оценивании различают два подхода: точечное оценивание и интервальное оценивание.

Точечное оценивание. Пусть распределение случайной величины x — заданная ф-ция $p(x|a)$ с неизвестными параметрами a , а $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ — вектор возможных значений x . Точечное оценивание заключается в выборе ф-ции $\hat{a}_N = \hat{a}(x)$, значение k -рой при заданном x можно использовать вместо параметра a в качестве его приближённого значения. Ф-цию $\hat{a}(x)$ наз. оценкой a параметра a , принцип выбора ф-ции — методом оценивания. Очевидно, что можно предложить много оценок, поэтому необходимо изучить следующие осн. свойства оценок.

Состоятельность. При увеличении объёма N наблюдений (измерений) оценка должна приближаться к истинному значению параметра. Оценку \hat{a}_N называют состоятельной по вероятности, если для любых $\epsilon, \eta > 0$ существует такое N , что вероятность реализации неравенства $|\hat{a}_N - a| > \epsilon$ будет меньше η . Примером состоятельной оценки служит выборочное среднее $\hat{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_N)/N$, k -рое является оценкой ср. значения величины $x = \int dx x p(x)$, если ф-ция плотности вероятности $p(x)$ имеет конечную дисперсию.

Смещение. Под смещением оценки \hat{a}_N принято понимать отклонение её ср. значения $\hat{a}_N(x)$ от истинного значения a : $b_N(\hat{a}_N) = \hat{a}_N - a$. Оценку \hat{a}_N наз. несмещённой, если при любых N и a имеем $b_N(\hat{a}_N) = 0$, или $\hat{a}_N = a$. Несмещённая оценка обычно предпочтительнее смещённой, т. к. смещение является систематич. ошибкой в оценке, k -рая зависит от истинного значения параметра a и поэтому редко поддаётся вычислению. Выборочное среднее является несмещённой оценкой, тогда как выборочная дисперсия $\hat{s}^2 = \sum (x_n - \hat{x})^2/N$ является смещённой оценкой дисперсии s^2 .

Эффективность. Простейшей характеристи-

ной точности оценки является ср. значение квадрата её расстояния от истинного значения:

$$\hat{D}^2(\hat{a}_N) = M\{(\hat{a}_N - a)^2\} = D(\hat{a}_N) + b_N^2,$$

где $D(\hat{a}_N)$ — дисперсия оценки \hat{a}_N , равная

$$D(\hat{a}_N) = M\{[\hat{a}_N - M(\hat{a}_N)]^2\}.$$

Дисперсия характеризует «ширину» распределения, т. е. «шумовую» составляющую ошибки $\hat{a}_N(\hat{a}_N)$ оценки \hat{a}_N . Поэтому в классе оценок с данным смещением b_N предпочтительнее оценка с мин. дисперсией. Справедливо неравенство Крамера — Рао:

$$D(\hat{a}_N) \geq 1/db \cdot da^2 / I_{\hat{a}_N}(a) \geq 1/db \cdot da^2 / I_x(a), \quad (1)$$

k -рое и определяет максимально достижимую точность (в смысле $\hat{D}^2(\hat{a}_N)$) в классе оценок с данным смещением b_N по выборке x . Величину

$$I_{\hat{a}_N}(a) = M\left\{\left(\frac{\partial \ln q}{\partial a}\right)^2\right\} = -M\left\{\frac{\partial^2 \ln q}{\partial a^2}\right\},$$

где $q(\hat{a}_N|a)$ — ф-ция плотности распределения \hat{a}_N , называет количеством информации по Р. Фишеру (R. Fisher) о параметре a в оценке $\hat{a}_N(x)$. Величину

$$I_x(a) = M\left\{\left(\frac{\partial \ln L}{\partial a}\right)^2\right\} = -M\left\{\frac{\partial^2 \ln L}{\partial a^2}\right\}, \quad (2)$$

где $L(a|x) = \prod p(x_n|a)$ — ф-ция правдоподобия, а $p(x|a)$ — плотность ф-ции распределения x , называет количеством информации по Р. Фишеру о параметре в выборке x . В классе несмещённых оценок

$$D(\hat{a}_N) \geq 1/I_{\hat{a}_N}(a) \geq 1/I_x(a) \quad (3)$$

и информац. смысл величин $I_{\hat{a}_N}(a)$ и $I_x(a)$ становится очевидным: их значение определяет минимально достижимое расстояние $\hat{a}_N(x)$ от a . Первое неравенство в (1), (3) превращается в равенство лишь тогда, когда ф-ция плотности распределения оценки имеет экспоненц. форму:

$$q(\hat{a}|a) = \exp[A(\hat{a}) + B(\hat{a}) + C(a)]. \quad (4)$$

Если

$$I_{\hat{a}_N}(a) = I_x(a), \quad (5)$$

то и второе неравенство в (1), (3) превращается в равенство. Такую оценку называют эффективной в смысле Крамера — Рао. Оценку, для k -рой выполняется равенство (5), т. е. такую, в k -рой количество информации о параметре a такое же, как в самой выборке x , называют достаточной статистикой. Условием существования достаточной статистики $\hat{a}(x)$ является факторизация ф-ции правдоподобия: $L(a|x) = g(a, \hat{a})h(\hat{a}, x)$. Неравенство Крамера — Рао полезно тем, что позволяет ещё на стадии планирования эксперимента оценить максимально достижимую точность измерения параметров изучаемых распределений.

Требования (3) и (4) являются достаточно жёсткими, поэтому при конечных N эфф. оценки редки. В связи с этим рассматривают поведение $D(\hat{a}_N)$ при $N \rightarrow \infty$ и наз. оценку асимптотически эффективной, если при $N \rightarrow \infty$ $D(\hat{a}_N)I_x(a) \rightarrow 1$. Заметим, что асимптотич. несмещённость следует из состоятельности оценки. Рассмотрим наиб. общие и распространённые методы получения точечных оценок.

Метод максимума правдоподобия (подробнее см. *Максимального правдоподобия метод*).

В этом методе вероятности реализации вектора наблюдений x , $P(x|a) = \prod_{n,p} p(x_{n,p}|a)$, после подстановки в неё реализовавшихся значений x рассматривают как ф-цию параметров a и называют ф-цией правдоподобия: $L(a|x) = P(x|a)$. В качестве оценки в методе макс. правдоподобия для вектора параметров a берут то значение \hat{a} , к-рое соответствует макс. значению ф-ции правдоподобия. При нек-рых общих предположениях оценки в методе макс. правдоподобия состоятельны, асимптотически эффективны и асимптотически нормально распределены. При конечных N оценка в методе макс. правдоподобия имеет оптим. свойства только в том случае, когда существует достаточная статистика. Метод наименьших квадратов (подробнее см. *Наименьших квадратов метод*). В этом методе в качестве оценки вектора параметров a берут то значение \hat{a} , к-рое соответствует минимуму квадратичной формы.

$$\Phi = \sum_{n,m} [x_n - \bar{x}_n(a)] D_{nm}^{-1} [x_m - \bar{x}_m(a)],$$

где D — матрица ошибок измерений x_n . При нек-рых общих предположениях оценка в методе наим. квадратов состоятельна и асимптотически нормально распределена, но не является асимптотически эффективной. Если x_n — линейные ф-ции параметров a , то в классе линейных несмещённых оценок оценки \hat{a}_i в методе наим. квадратов имеют наим. дисперсию.

Метод моментов. Пусть m_i — выборочные моменты, $\mu_i(a) = \int x^i p(x|a)$ — моменты ф-ции плотности распределения, $\mu_i(a) = \int x^i p(x|a)$. В методе

моментов выбирают в качестве оценки параметров a решение $\hat{a}(x)$ системы ур-ний $\mu_i(a) = m_i$. Оценки в методе моментов состоятельны, асимптотически несмещёны, но не являются асимптотически эффективными.

χ^2 -метод. Если объект выборки x велик и данные x_n сгруппированы в *гистограмму*, то для оценки параметров a используют χ^2 -метод, являющийся частным случаем метода наим. квадратов. Пусть Y_i — число наблюдений, попавших в i -канал гистограммы, а $\bar{Y}_i(a)$ — их ожидаемое число:

$$\bar{Y}_i(a) = N \int_{x_i}^{x_{i+1}} dx p(x|a).$$

В качестве оценки параметров a берут значение $\hat{a}(Y)$, соответствующее минимуму квадратичной формы

$$\Phi = \sum_i [Y_i - \bar{Y}_i(a)]^2 / \bar{Y}_i(a),$$

либо модифицированный χ^2 -метод

$$\Phi = \sum_i [Y_i - \bar{Y}_i(a)]^2 / Y_i.$$

Оценки в χ^2 -методе и модифицированном χ^2 -методе состоятельны, асимптотически нормально распределены и асимптотически эффективны. Своё название эти методы получили по той причине, что при больших Y_i (приближение нормального распределения) $\Phi(a) = a$ распределено по χ^2 -распределению с числом степеней свободы $k = L - I - 1$, где L — число каналов гистограммы, I — число параметров.

Интервальное оценивание состоит в отыскании интервала $[a_1, a_2]$, к-рый с заданной вероятностью β содержит истинное значение параметра a . Др. словами, нужно найти такой интервал $[a_1, a_2]$ (как ф-цию вектора

наблюдений x), к-рый «накрывает» с вероятностью β истинное значение a при данном значении x . Это т. н. *доверительный интервал* с вероятностным содержанием β (или коэф. доверия β). Такое определение неоднозначно, его обычно доопределяют требованием минимальности длины среди всех интервалов с коэф. доверия β .

Пусть распределение $p(x|a)$ зависит от одного параметра a и $\hat{a}(x)$ — к.-л. точечная оценка a , ф-ция плотности вероятности к-рой равна $q(\hat{a}|a)$. Тогда центр доверит. интервала определяется как решение ур-ний

$$\int_{-\infty}^{\hat{a}(x)} d\hat{a} q(\hat{a}|a_1) = \frac{1-\beta}{2} = \int_{\hat{a}(x)}^{\infty} d\hat{a} q(\hat{a}|a_2).$$

Такой доверит. интервал может и не быть минимальным. Однако, если точечная оценка $\hat{a}(x)$ асимптотически эффективна, то при больших N этот интервал будет близок к минимальному.

Более общий подход к получению доверит. интервалов заключается в поиске такой ф-ции от оценки и параметра, распределение к-рой не зависит от искомого параметра. Напр., пусть вектор оценок \hat{a} распределён по многомерному Гауссу *распределению* со средним a и матрицей вторых моментов D . Тогда квадратичная форма $\Phi(\hat{a}, a) = (\hat{a} - a) D (\hat{a} - a)$ распределена по закону $\chi^2(I)$ (см. *Распределение*), к-рое не зависит от a . Задавая вероятность β того, что $\Phi(\hat{a}, a) \leq k_\beta$, находим k_β и доверит. область для a : $\Phi(\hat{a}, a) = k_\beta$, имеющую вид гиперэллипсоида с центром в точке a . Этот пример имеет практич. применение, т. к. асимптотически, при больших N , эти методы оценивания дают нормально распределённые оценки параметров.

Непараметрическое оценивание. В этом случае не делают к.-л. предположений о плотности ф-ции распределения. В качестве точечной оценки часто используют гистограмму. В этом методе оценивания численную ось, на к-рой определены x_n , делят на ряд областей r_j ($j = 1, 2, \dots, k$), называемых *к* и *а* и *л* м в гистограмме. Тогда $\hat{P}_N(x)$ задают константами \hat{p}_j в каждой области r_j , причём $\hat{p}_j = C(N) \sum_n \delta_j(x_n)$. Здесь $C(N)$ — коэф.

нормировки, $\delta_j(x)$ — индикаторная ф-ция области r_j :

$$\delta_j(x) = \begin{cases} 1, & x \in r_j, \\ 0, & x \notin r_j. \end{cases}$$

Более формально оценки ф-ции плотности вероятности записывают в виде

$$\hat{P}_N(x) = N^{-1} \sum_{j=1}^k \sum_{n=1}^N \delta_j(x_n) \delta_j(x).$$

Гистограмма является простой в вычислит. плане, но смещённой и несостоятельной оценкой. Поэтому используют более сложные, но состоятельные оценки, напр. метод ближайших соседей (см. *Непараметрические методы статистики*). В качестве точечной оценки ф-ции распределения можно взять выборочную ф-цию распределения:

$$P_N(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1, \\ n/N, & x_n < x \leq x_{n+1}, \\ 1, & x > x_N, \end{cases}$$

где подразумевается, что x_1, \dots, x_N расположены в порядке их возрастания. Эта оценка оказывается несмещённой и состоятельной. Ф-ция распределения $P(x)$ допускает и интервальную оценку. Рассмотрим статистику $D_N = \max |P_N(x) - P(x)|$, для к-рой асимптотич. распределением является $\lim F(N^{-1/2} D_N > z) =$

$= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \exp(-2n^2 \pi^2)$. Т. к. это распределение не зависит от $P(x)$, можно вычислить $d\beta$ для k -рого вероятности $\max |P_N(x) - P(x)|$ равна β , и задать доверит. зону для $P(x)$:

$$P_N(x) - d\beta < P(x) < P_N(x) + d\beta.$$

Считается, что асимптотич. распределение справедливо при $N \geq 80$.

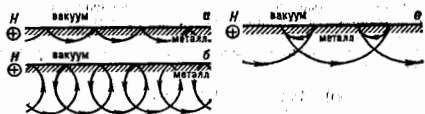
Лит.: Митропольский А. К. Теория статистических вычислений, 2 изд., М., 1971; Рао С. Р. Лекции статистических методов и их приложения, пер. с англ., М., 1968; Кендалл М. Стьюарт А. Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973; Статистические методы и экспериментальной физике, пер. с англ., М., 1976.

В. П. Жидков, С. В. Каменко.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ — см. Равновесие статистическое.

СТАТИЧЕСКИЙ СКИН-ЭФФЕКТ — концентрация токочных линий (постоянного тока) вблизи поверхности электронного проводника, помещенного в сильное магн. поле H . С. с.-э. наблюдается при низких темп-рах, когда осуществляется условие $\omega_c \tau \gg 1$, где ω_c — циклотронная частота электронов, а τ^{-1} — частота столкновений электронов в объёме проводника. Это означает, что время свободного пробега электрона во много раз больше периода обращения по орбите. При этом токочные линии концентрируются в слое толщиной порядка радиуса электронной орбиты в магн. поле $r_H = v_F / \omega_c$, где v_F — фермиевская скорость. В отличие от скин-эффекта в перем. поле, когда весь ток эконцентрирован в приповерхностном слое, при С. с.-э. плотность пост. тока I при удалении в глубь образца стремится не к нулю, а к значению, характерному для массового образца, когда можно не учитывать столкновения электронов с границами образца.

Причина С. с.-э. заключается в существовании вблизи границы проводника слоя (толщиной $\sim r_H$) с большей, чем в объёме, проводимостью. При $\omega_c \tau \gg 1$ поперечные (относительно H) компоненты тензора проводимости для металлов с замкнутыми ферми-поверхностями тем больше, чем чаще происходят столкновения электронов с границей. При этом величина компонент тензора проводимости в магн. поле значительно меньше проводимости при $H = 0$ (см. *Гальваномагнитные явления, Магнетосопромирование*). Электроны из приграничного слоя толщиной $\sim r_H$ обязательно (при каждом обороте вокруг магн. поля H) сталкиваются с границей, что и приводит к существованию хорошо проводящего слоя вблизи границы (рис., а, б).

Конкретное значение приповерхностной проводимости σ , зависит от состояния границы образца (атомно-гладкая или шероховатая), а также от структуры ферми-поверхности проводника. В частности, если ферми-поверхность имеет нек. плосостей, то при столкновении с границей образца электрон может «перескочить» с одной плоскости на другую (и наоборот) и в результате рассеян не; рис., в). Это существенно изменяет движение электрона под действием магн. поля по сравнению с его движением в объёме проводника и проявляется в величине приповерхностной проводимости. Макс. отличие приповерхностной проводимости от объёмной имеет место тогда, когда в объёме



Типы открытых траекторий, возникающих при отражении электрона от границы металл — вакуум: а, б — электрон оставлен на одной и той же плоскости поверхности Ферми; в — электрон поочередно «перескакивает» с электронной плоскости на другую.

проводника электроны движутся по замкнутым орбитам, а за счёт столкновения с границей — по открытым траекториям (рис.). Тогда проводимость вблизи границы σ порядка объёмной σ_0 при $H = 0$ и, естественно, значительно больше, чем в объёме.

При больших плотностях тока становится существенным влияние собств. магн. поля тока H_j на движение электронов. Т. к. в центре пластины (проволочки) $H_j = 0$, то роли H_j и H противоположны: внеш. магн. поле концентрирует токочные линии у поверхности, а собств. магн. поле тока — в центре (см. *Личн-эффект*).

Неососредот. наблюдение С. с.-э. затруднительно. С. с.-э. проявляется по зависимости сопротивления образцов конечной толщины (пластин, проволочек) от магн. поля (см. нижеприведенную табл., а также табл. в ст. *Размерные эффекты*).

Выражения для проводимости проводников конечных размеров, демонстрирующих статич. скин-эффект (концентрация металлы; J, H)

Поверхность	Пластина толщиной d ; σ_0 — проводимость, усредненная по толщине	Проволока радиуса R ; σ_0 — проводимость, усредненная по сечению
Зеркальная	$\sigma = \sigma_0 (r_H/d)$, $d < r_H (\omega_c \tau)^2$	$\sigma = \sigma_0 (r_H/R)^2$, $R < v_F \tau$
Шероховатая	$\sigma = \sigma_0 (r_H/d) (\omega_c \tau)^{-1}$, $d < v_F \tau$	$\sigma = \sigma_0 (r_H/R) (\omega_c \tau)^{-1}$, $R < v_F \tau$

Для наблюдения С. с.-э. используют металлы, у к-рых объёмная проводимость в магн. поле при $\omega_c \tau \gg 1$ заметно меньше, чем при $H = 0$. В этом смысле особенно показательны образцы конечных размеров из композиц. металлов или собств. полупроводников (число электронов равно числу дырок), т. к. у них в магн. поле объёмная поперечная проводимость σ ($\omega_c \tau$)² меньше, чем при $H = 0$. При выборе размеров образца (толщины пластины d , радиуса проволочки R) необходимо, чтобы роль приповерхностного слоя была заметной и не перекрывалась проводимостью «средней», в к-рой электроном вовсе не сталкиваются с границей.

Если магн. поле H параллельно грани пластины из композиц. металла (либо собств. полупроводника), то $\sigma_{\parallel} = \sigma_0 / (1 + W \omega_c^2 \sin^2 \varphi)$, где W — параметр, определяющий степень зеркальности отражения электронов границами образца; φ — угол между J и H . С. с.-э. определяет проводимость образца, когда отражение зеркально ($W = 0$) при $d < r_H (\omega_c \tau)^2$, когда отражение диффузно ($W = 1$) при $d < v_F / \sin \varphi$.

Чувствительность С. с.-э., как и др. гальваномагн. явлений, к геометрии ферми-поверхности металлов, а также к характеру отражения электронов границей образца делает его источником информации не только об электронном энергетич. спектре проводников, но и о структуре его границ. Эффект, аналогичный С. с.-э., должен наблюдаться при наличии плоских дефектов внутри проводника (напр., границ кристаллитов), столкновения с к-рыми в сильном магн. поле ($\omega_c \tau \gg 1$) могут привести к концентрации токочных линий вблизи дефектов.

Лит.: Песчанский В. Г. Статистич. скин-эффект, в сб.: Электроны проводимости, под ред. М. И. Каганова, В. С. Зельмана, М., 1985.

М. И. Каганов, В. Г. Песчанский.

СТАЦИОНАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИП — см. Наименьшего действия принцип.

СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ в термодинамике — состояние, в к-ром определяющие его термодинамич. параметры (напр., темп-ра, хим. потенциал компонент смеси, массовая скорость) не зависят от времени. С. с. могут быть как равновесными (см. *Рав-*

новое состояние), так и неравновесными в зависимости от граничных условий, накладываемых на систему. Неравновесие С. с. возможно лишь в том случае, когда термодинамич. система открыта в отношении процессов переноса и термодинамич. силы, а следовательно, и термодинамич. потоки на границах системы удерживаются постоянными (см. Термодинамика неравновесных процессов). В этом случае вся производимая в системе энтропия отводится из неё в окружающую среду (термостат). В том случае, когда кинетические коэффициенты можно считать постоянными, С. с. соответствует мин. производству энтропии (см. Пригожина теорема).

Лит.: Гроот С. де, Мавур П., Неравновесная термодинамика, пер. с англ., М., 1964. Д. Н. Зубарева.

СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ квантового механической системы — состояние физ. систем, в к-ром её энергия имеет определённое, не меняющееся со временем значение. В С. с. ср. значения всех физ. величин, характеризующих систему, также не меняются с течением времени.

СТАЦИОНАРНЫЕ НЕРАВНОВЕСНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ частиц или волн по импульсам (волновым числам) — распределения, обращаемые в нуль интеграл столкновений в кинетическом уравнении и полностью определяющиеся постоянными в пространстве импульсов (волновых чисел) потоком сохраняющихся величин, напр. энергии, импульса, числа частиц (или волнового действия для квазичастиц). С. н. р. называются также коломгоровскими спектрами (КС).

Впервые А. Н. Колмогоровым и А. М. Обуковым (1941) в теории турбулентности несжимаемой жидкости было построено в интервале масштабов, промежуточных между масштабами возмущаемых и эффективно затухающих движений, универсальное С. н. р. энергии по волновым числам k — $W(k)$ — известный КС гидродинамич. турбулентности:

$$W(k) = AP_1^{2/3} k^{-5/3}, \quad (1)$$

где A — константа, P_1 — интегральный поток энергии по спектру волновых чисел k .

При выводе ф-лы (1) использована гипотеза о локальности турбулентности, т. е. о том, что существенно взаимодействуют между собой только волновые движения с размерами одного порядка. Эта гипотеза для турбулентности в несжимаемой жидкости (сильная турбулентность) строго не доказана.

В физ. средах, в к-рых взаимодействие волн или частиц можно описать кинетич. ур-ниями для квазичастиц или частиц, нахождение С. н. р. сводится к решению кинетич. ур-ний. В этом случае локальность С. н. р. соответствует сходности интеграла столкновений.

Подобно термодинамически равновесным распределениям С. н. р. обращают в нуль интеграл столкновений, однако они существуют только при наличии потока к-л. сохраняющейся величины в импульсном пространстве, подерживаемом источником и стоком. Начиная со слаботурбулентных С. н. р. (КС) волн, полученных В. Е. Захаровым (1965), идея об эстафетной передаче по масштабам интегралов движения (сохраняющихся величин) была широко использована при рассмотрении турбулентности в плазме, твёрдом теле, жидкости; были получены изотропные и анизотропные С. н. р. (КС), соответствующие переносу постоянных в импульсном пространстве (или пространстве волновых чисел) потоков энергии, импульса, числа частиц, волнового действия.

Стационарные неравновесные распределения (коломгоровские спектры) волн с распадными законами дисперсии. Если дисперсия волн к-л. одного типа описывается распадными условиями $\omega(k) = \omega(k_1) + \omega(k_2)$, то интеграл столкновений I_{st} , получаемый усреднением дв-

намич. ур-ний, может быть записан следующим образом:

$$I_{st}[n(k)] = \int T(kk_1k_2) - R(kk_1k_2) - R(k_2kk_1) dk_1 dk_2, \\ R(kk_1k_2) = 2\pi \int V(kk_1k_2) \delta(k - k_1 - k_2) \delta(\omega(k) - \omega(k_1) - \omega(k_2)) \times [n(k_1)n(k_2) - n(k)n(k_1) - n(k)n(k_2)], \quad (2)$$

где $n(k_2)$ — плотность числа квазичастиц, $V(kk_1k_2)$ — матричный элемент трёхволнового взаимодействия, $\delta(x)$ — дельта-функция. В однородной и изотропной среде при масштабной инвариантности закона дисперсии и матричного элемента относительно своих аргументов, а именно

$$\omega(k) = \varepsilon \omega(k), \quad V(kk_1k_2) = \varepsilon^2 V(k, k_1, k_2), \quad (3)$$

С. н. р. числа квазичастиц по волновым числам $n(k)$, обращающие в нуль интеграл столкновений (2) и соответствующие пост. потоку энергии P_1 , имеет вид:

$$n(k) = AP_1^{1/d} k^{-d-2}. \quad (4)$$

В ур-ниях (3) и (4) $\varepsilon = \text{const}$, α и β — константы, характеризующие степень однородности закона дисперсии и матричного элемента, d — размерность волновых векторов.

Так, напр., для капиллярных волн на поверхности жидкости $d = 2$, $\beta = 1/4$ и локальное изотропное С. н. р. числа квазичастиц, соответствующее пост. потоку энергии P_1 , имеет вид:

$$n(k) = AP_1^{1/2} k^{-12/5}. \quad (5)$$

В среде, обладающей аксиальной симметрией относительно выделенного направления ξ , при определённой масштабной инвариантности закона дисперсии и матричного элемента трёхволнового взаимодействия, а именно

$$\omega(k, k_1) = k_1^\alpha |k_1|^\beta, \quad V(kk_1k_2) = \varepsilon^2 V(k, k_1, k_2, \mu k_1, \mu k_2, \mu k_1) = \\ = \varepsilon^2 \mu^\beta V(k, k_1, k_2, \mu k_1, \mu k_2, \mu k_1), \quad (6)$$

анизотропное С. н. р. числа квазичастиц по волновым векторам, соответствующее пост. потоку импульса R в направлении ξ , имеет вид:

$$n(k) = A \mathcal{P}^{2/\alpha} |k_1|^{-(1-\alpha+\beta)\alpha} |k_2|^{-(1-\alpha+\beta)\alpha}, \quad (7)$$

где k_1, k_2 — компоненты волнового вектора, соответственно параллельная и перпендикулярная ξ . В частности, для ионно-звуковых колебаний в плазме, помещённой в направленное по оси x сильное магн. поле ($a = 1$, $b = 2$, $u = v_s$, $v = 0$), локальное анизотропное С. н. р. числа квазичастиц

$$n(k) = A \mathcal{P}^{1/2} |k_x|^{-3/2} |k_{\perp}|^{-2}, \quad (8)$$

где \mathcal{P} — поток импульса, направленный по оси x . Локальные анизотропные С. н. р. получены для бездиспергентных волн Россби, косых электронно-дрейфовых, ионно-дрейфовых, электронно-звуковых, магнитозвуковых, альвеновских волн в плазме, волн плотности в гравитирующих астрофиз. объектах.

Стационарные неравновесные распределения волн с нераспадным законом дисперсии. В случае дисперсии волн, не описываемой распадными условиями, интеграл столкновений I_{st} может быть записан следующим образом:

$$I_{st}[n(k)] = 4\pi \int T(kk_1k_2) \delta(k - k_1 - k_2) \times \\ \times \delta(\omega(k) + \omega(k_1) - \omega(k_2) - \omega(k_3)) [n(k_1)n(k_2)n(k_3) + \\ + n(k)n(k_1)n(k_2) - n(k)n(k_1)n(k_3) - n(k)n(k_1)n(k_3))] \times \\ \times dk_1 dk_2 dk_3, \quad (9)$$

где $T(kk_1k_2k_3)$ — матричный элемент взаимодействия.

В однородной и изотропной среде при аналогичной выражению (3) масштабной инвариантности закона дисперсии и матричного элемента относительно своих аргументов С. н. р. числа квазичастиц по волновым числам, соответствующее пост. потоку энергии P_1 (или волнового действия P_0), имеет вид:

$$n^{(i)}(k) = A_i P^{1/3} k^{-v_i}, \quad (10)$$

где $v_i = [3d + 2\beta + \alpha(i-1)]/3$, A_i — константы, $i = 0, 1$ соответствует пост. потоку волнового действия, энергии. Так, напр., для гравитад. волн на поверхности глубокой жидкости ($\alpha = 1/2$, $\beta = 3$) имеются локальные С. н. р. числа квазичастиц, соответствующие пост. потоку энергии в область больших волновых чисел ($v_i = 4$), т. е. передаче энергии от больших масштабов к малым, и пост. потоку волнового действия в область малых волновых чисел ($v_0 = 23/6$), т. е. от малых масштабов к большим.

Стационарные неравновесные распределения частиц. Интеграл столкновений Больцмана I_{st} может быть записан следующим образом:

$$I_{st}((p)) = \int T(p p_1, p_2 p_3) \delta(p + p_1 - p_2 - p_3) \times \\ \times \delta(\mathcal{E} + \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_3) / ((p_1)(p_2) - I(p_1)) dp_1 dp_2 dp_3, \quad (11)$$

где $T(p p_1, p_2 p_3)$ — матричный элемент взаимодействия частиц, $I(p_1)$ — ф-ция распределения частиц, \mathcal{E} , p — соответствующие энергия, импульс s -й частицы.

В однородной и изотропной среде при масштабной инвариантности зависимости энергии от импульса $\mathcal{E}(p)$ и матричного элемента относительно своих аргументов, а именно

$$\mathcal{E}(p) = \mu^s \mathcal{E}(p), \quad T(\mu p, \mu p_1, \mu p_2, \mu p_3) = \mu^s T(p p_1, p_2 p_3), \quad (12)$$

С. н. р. частиц по импульсу, соответствующее пост. потоку энергии $P_1 (i = 1)$ или пост. потоку частиц $P_0 (i = 0)$, имеет вид:

$$j^{(i)}(p) = A_i \mu^{1/2} p^{-v_i}, \quad (13)$$

где $v_i = [3d + 2\beta + \alpha(i-1)]/2$, $i = 0, 1$.

Так, для перелетчивых заряд. частиц, взаимодействующих по закону Кулона с учётом статической экранировки ($\alpha = 2$, $\beta = -2$), имеется локальное С. н. р. частиц, соответствующее пост. потоку энергии в импульсном пространстве ($v_i = +5/2$). Именно это С. н. р. обращает в нуль также интеграл столкновений в форме Ландау (см. *Кинетические уравнения для плазмы*).

Лит.: Захаров В. Е., Колмогоровские спектры в задачах слабой турбулентности, в кн.: Основы физики плазмы, т. 2, М., 1984; Кадомацев В. Е., Конторович В. М., Теория турбулентности в газодинамике и плазме, «Изв. вузов. Радиофизика», 1974, т. 17, с. 511; Кузнецов В. А., О турбулентности волнового звука и плазмы в магнитном поле, «ИЗВ. АН УССР», 1972, т. 62, с. 584; Кац А. В. и др., Точные степенные решения кинетических уравнений для частиц, «ЖТФ», 1976, т. 71, с. 178; Карась В. И., Моисеев С. С., Новиков В. Е., Неравновесные стационарные распределения частиц в твердотельной плазме, «ИЗТФ», 1976, т. 71, с. 1421. В. И. Карась.

СТАЦИОНАРНЫЙ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС — случайный процесс $\{\xi_t, t \in R^1\}$, определённый для всех моментов времени $-\infty < t < \infty$, стохастич. характеристики к-рого не зависят от выбора нач. момента отсчёта (т. е. не меняются при замене $t \rightarrow t + s, s \in R^1$). Более точно это означает, что для любого набора моментов времени t_1, \dots, t_n совместная ф-ция распределения вероятностей значений С. с. п. $\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n}$ в эти моменты времени

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{\omega: \xi_{t_1}(\omega) \leq x_1, \dots, \xi_{t_n}(\omega) \leq x_n\}, \\ \omega \in \Omega$$

(Ω — вероятностное пространство, на к-ром определены все случайные величины ξ_t) совпадает с ф-цией

распределения $F_{t_1+\varepsilon, \dots, t_n+\varepsilon}$ для значений процесса в моменты $t_1 + \varepsilon, \dots, t_n + \varepsilon$ (стационарность в узком смысле). Иногда стационарность процесса $\{\xi_t, t \in R^1\}$ понимают более широко, а именно: процесс наз. стационарным в широком смысле, если его ср. значение $\langle \xi_t \rangle$ не зависит от t , а ковариация $\langle \xi_{t_1}, \xi_{t_2} \rangle$ имеет вид:

$$\langle \xi_{t_1}, \xi_{t_2} \rangle = \langle \xi_t, \xi_{t_1} \rangle - \langle \xi_t, t \rangle \cdot \langle \xi_{t_2}, t \rangle = B(t_1 - t_2),$$

где $B(\tau)$ — положительно определённая ф-ция. Гауссовский случайный процесс, стационарный в широком смысле, стационарен и в обычном (узком) смысле. Марковский случайный процесс $\{\xi_t, t \in R^1\}$ с переходной ф-цией

$$P_{t_1, t_2}(x_1, x_2) = P\{\xi_{t_2}(\omega) < x_2 / \xi_{t_1}(\omega) = x_1\}$$

(где $P(A/B)$ — условная вероятность события A при условии, что произошло событие B) является стационарным в том, и только в том случае, когда распределение F_t значений процесса ξ_t в моменты времени t одинаковы для всех t и для всех t_1 и t_2 переходная ф-ция

$$P_{t_1, t_2}(x_1, x_2) = P_{t_1 - t_2}(x_1, x_2),$$

т. е. зависит лишь от длительности промежутка времени между t_1 и t_2 .

Лит.: Гихман И. И., Скороход А. В., Введение в теорию случайных процессов, 2 изд., М., 1977. Р. Л. Мильос. СТЕКЛА — твердотельные системы, не обладающие пространственным упорядочением (транслационным и ориентационным) в расположении атомов, их магн. моментов, электрич. дипольных моментов молекул и т. д. (в смысле дальнего порядка — см. *Дальний и ближний порядки*). С. характеризуются временным упорядочением: каждый элемент системы всё время остаётся в нек-рой конечной области конфигурац. пространства, т. е. корреляция между его положениями не убывает за большие промежутки времени, так что система не является эргодической (см. *Эргодичность*). Переход системы в состояние С. происходит при повышении темп-ры T , и это явл. в амерзании к ем (стеклованию). Осн. свойство С. — наличие большого (быстро растущего с размером системы) числа метастабильных (долгоживущих) макросостояний, приводящие к явлениям медленной релаксации и зависимости состояний системы от её предистории (характера изменения темп-ры, давления, магн. поля и т. д.).

С. естественно классифицировать по типу переменных, испытывающих замерзание. При этом каждому С. можно сопоставить пространственно упорядоченное (регулярное) состояние с переменными того же типа. Известны С.: позиционные, силовые, дипольные, электрические квадратичные, протонные, сверхпроводниковые и др. Среди структурных (позиционных) С. различают металлические, ковалентные, полимерные. Все они характеризуются замерзанием движения атомов и молекул (см. *Стеклообразное состояние*). Регулярное состояние, соответствующее абс. минимуму энергии, — кристаллическое. Металлич. С. (напр., FeP, ZrCu) и ковалентные С. (SiO_2, Ge_2Se_7) являются метастабильными фазами, способными к кристаллизации (для SiO_2 время кристаллизации $\sim 10^8$ лет). Эти С. образуются при достаточно быстром охлаждении; при медленном охлаждении возникает кристаллич. состояние (см. *Металлические стёкла, Аморфные и стеклообразные полупроводники* [1]).

То же относится и к полимерным С., образованным полимерами с регулярной последовательностью мономеров (напр., полиэтилен). Полимеры с нерегулярными последовательностями мономеров (напр., полистирол, пропилен) и сетчатые (разветвлённые) полимеры образуют только стеклообразные твёрдые фазы; в этих случаях неупорядоченность твёрдой фазы вторична, она является следствием первичной (аморфной) нерегулярности молекулярной структуры.

Это же относится и к остальным типам С. {2}. Так, *слабое стекло* (регулярный аналог — антиферромагнетик) возникает в твердотельных системах с неупорядоченным расположением магн. атомов (первично беспорядок). В отношении трансляц. порядка система может быть как кристаллической (напр., $\text{Cu}_{1-x}\text{Mn}_x$, $x < 1$), так и аморфной ($\alpha = \text{AlGd}$) [2,3,4].

Дипольные С. возникают в системах с неупорядоченно расположенными диполями (как магнитными, так и электрическими). В неупорядоченных *твёрдых растворах* с редко расположенными магн. атомами (напр., $\text{LiHo}_x\text{Y}_{1-x}\text{F}_4$ при $x < 1$) магнитное *обменное взаимодействие* мало и определяющим становится магн. дипольное взаимодействие. Его закономерный характер и случайность в пространственном расположении диполей приводит к образованию магн. дипольного С. В металлч. твёрдых растворах с малой концентрацией магн. атомов переходных металлов (напр., $\text{Cu}_{1-x}\text{Mn}_x$, $x < 1$) роль закономерного взаимодействия играет РККН-обменное взаимодействие (через электронную проводимость).

Аналогичная ситуация возникает в электрических дипольных С., напр. в соединениях типа $\text{K}(\text{Ta}_{1-x}\text{Zr}_x\text{O}_7)$, где $\text{Z} = \text{Nb, Li, Na}$; $x < 1$. В элементарной ячейке KTaO_3 есть неск. эквивалентных децентральных положений, в x -рых может оказаться примесь замещения Z, создавая при этом локальный дипольный момент. При низких темп-рах электрич. дипольное взаимодействие приводит к *замерзанию* диполей (атомов Z) в неупорядоченном состоянии. Если концентрация примеси в веществе (матрице) мала ($x \sim 0,05 - 0,1$), то определяющую роль играет короткодействующее знакоопositное взаимодействие между диполями (возникающее из-за большой поляризуемости матрицы). Оно приводит к переходу вещества в регулярную сегнетоэлектрич. фазу (см. *Сегнетоэлектрики*).

Соединение $(\text{KCN})_x(\text{KBr})_{1-x}$ при $x \sim 0,5$ представляет собой пример электрич. квадрульного (ориентационного) С. Определяющим здесь является взаимодействие случайно расположенных одноосных молекул CN через поле упругих напряжений в матрице, являющееся квадрульным (при более низких темп-рах возможно образование дипольного С. за счёт слабого дипольного взаимодействия молекул CN). Квадрульным С. является также твёрдый раствор орто- и параводорода при концентрации $x < 0,56$ ортомолекул H_2 , k -рые за счёт формы обладают электрич. квадрульным моментом; при больших x реализуется фаза с дальним порядком трансляц. и ориент. типов.

Протонным С. называется низкотемпературное состояние, возникающее в смешанных кристаллах $\text{Rb}_{1-x}(\text{NH}_4)_x\text{H}_2\text{PO}_4$. Чистые кристаллы RbH_2PO_4 (RDP) и $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (ADP) являются членами т.н. семейства KDP (KH_2PO_4) и имеют одинаковые решётки с близкими параметрами, причём RDP при низких темп-рах является сегнетоэлектриком, а ADP — анти-сегнетоэлектриком. Смешанные кристаллы KDP $(1-x)$ (ADP) $_x$ в интервале $0,22 < x < 0,8$ обладают неупорядоченным состоянием, характеризующимся замораживанием движения протонов на водородных связях.

Сверхпроводниковое С. может образовываться в в. н. гранулах, сверхпроводниках, помещённых в магн. поле $H \geq \Phi_0/l^2$, где квант магн. потока $\Phi_0 = hc/4e$, l — характерный масштаб неоднородности системы (порядка или больше ср. расстояния между центрами гранул). Такие сверхпроводники состоят из гранул сверхпроводящего вещества, помещённых в несверхпроводящую матрицу и связанных между собой туннельными (джозефсоновскими) контактами. Сверхпроводящие С. характеризуются замороженным неупорядоченным распределением джозефсоновских токов через межгранульные контакты; роль первичного беспорядка играет случайность в расположении гранул, приводящая к случайному распределению величин магн. потоков в пространстве между гранулами.

В слабом магн. поле $H \ll \Phi_0/l^2$ гранулоидн. системы ведут себя как обычные *сверхпроводники второго рода*. Регулярным аналогом является община сверхпроводящая фаза с *решёткой вихрей Абрикосова* [3].

Основным наблюдаемым признаком перехода системы в состояние С. является резкое замедление релаксации возмущений при понижении темп-ры (см. *Кооперативные явления*). Так, сдвиговая вязкость η позиционированного С. возрастает более чем на 12 порядков с приближением к точке замерзания, причём её поведение часто описывается эмпирич. законом Фегеля — Фулчера:

$$\eta \sim \alpha \exp\{\beta_0/(T - T_0)\}, \quad (1)$$

где β_0 , T_0 — параметры, получаемые экспериментально. Условно точкой замерзания T_f считают темп-ру, при к-рой η достигает 10^{12} пуаз ($T_f > T_0$). Аналогично замедление магн. релаксации наблюдается в спиновых С., в к-рых макс. время релаксации

$$\tau_{\text{макс}} \sim (T - T_f)^{-\alpha},$$

где $\alpha \approx 7 - 9$.

В состоянии С. ($T < T_f$) релаксация возмущений происходит медленно и в широком интервале времён может быть описана как логарифмич. зависимость параметра порядка от времени. Др. важнейшим свойством С. является зависимость его характеристик от истории. Приведённые свойства С. свидетельствуют о наличии широкого спектра времён релаксации, граница к-рого $\tau_{\text{макс}}$ больше времени наблюдения. Для С., обладающих замороженным первичным беспорядком, вопрос о конечности или бесконечности τ связан с вопросом (не имеющим пока общего решения) о существовании фазового перехода в состоянии С. Фазовый переход экспериментально наблюдается для большинства спиновых С. При этом вблизи точки замерзания T_f имеет особенность не только температурная зависимость времени релаксации $\chi(T)$, но и (при воздействии внеш. поля) обобщённая восприимчивость $\chi(T)$. В пост. поле H функция $\chi(T)$ имеет, как правило, излом в точке $T = T_f$. В перем. поле частоты ω особенность имеет $\text{Re } \chi(\omega)$ и $\text{Im } \chi(\omega)$. Кроме того, T_f зависит от ω . В области низких частот особенности $\chi(\omega)$ связаны с наличием в С. шума со спектром $1/\omega$.

Ключевая теория С. пока не построена. Одной из качественных концепций является понятие *фрустрации* [2—3]. Статистич. система наз. фрустрированной, если взаимодействия между её разл. элементами конкурируют, т. е. предьявляют несовместимые требования к локальной структуре, соответствующей минимуму свободной энергии. Простейшие примеры фрустрированной системы — квадратная ячейка спинов с одним положительным обменным интегралом $J > 0$ и тремя отрицат. интегралами $J < 0$ или треугольная ячейка спинов со всеми $J < 0$. В результате компромисса возникает принципиально новое состояние, к-рое при наличии первичного беспорядка оказывается С. Пример позиционных С. показывает, что наличие первичного беспорядка не является обязательным, его роль может сыграть флуктуационно возникшая неоднородность, замороженная при быстром охлаждении. Фрустрация в случае металлич. С. обеспечивается тем, что локальная энергетически выгодная конфигурация атомов имеет икосаэдр. симметрию, к-рая не может быть реализована в трёхмерной периодич. решётке. Иногда это приводит к образованию *квазикристаллов*, обладающих дальним ориентач. порядком при отсутствии трансляционного, в др. случаях возникает С. В магн. и электрич. С. осн. источником фрустрации является конкуренция ферро- и антиферромагн. взаимодействий; кроме того, фрустрация может возникнуть и при часто антиферромагнитном взаимодействии, напр. в треугольной или кубической граицентриров. кристаллич. решётках. Неупорядоченная спиновая система, ее обладающая фрустрацией, обычно является не С., а, напр., простым ферромагнетиком.

Ряд низкотемпературных свойств С. (теплоёмкость, теплопроводность и т. п.) хорошо описывается представлением о двухуровневых туннельных системах (группы атомов, спинового кластерах) с широким распределением энергетич. параметров [4].

Лит.: J. A. K. J. J., Models of the glass transition, «Rep. Progr. Phys.», 1986, в. 49, p. 171; B. Lindet K., U. O. и G. A. P., Spin glasses. Experimental facts, theoretical concepts, and open questions, «Rev. Mod. Phys.», 1986, в. 58, p. 801; В. Я. и О. У. В. М., и др., Система дисоросованных магнитов как модель спинового стекла, «ФЗЖТФ», т. 29, с. 343; А. Р. 1119; W. A., 2-Level states in glasses, «Rep. Progr. Phys.», 1987, в. 50, p. 1657. М. В. Фейсальман.

СТЕЛЛОБРАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ (структуры стекла) — аморфное состояние вещества, формирующееся при затвердевании переохлаждённого расплава. Обратимость перехода на С. с. в расплав и из расплава в С. с. (стеклование) является особенностью, к-рая отличает С. с. от др. аморфных состояний. Постепенное возрастание вязкости расплава препятствует кристаллизации вещества, т. е. переходу к термодинамически более устойчивому кристаллич. состоянию с меньшей свободной энергией. Процесс стеклования характеризуется температурным интервалом. Переход вещества из С. с. в кристаллическое является *фазовым переходом* 1-го рода.

В С. с. может находиться значит. число простых веществ (S, Be, As, P), оксидов (B_2O_3 , SiO_2 ; GeO_2 , As_2O_3 , SnO_2 , FeO , P_2O_5), водных растворов (H_2O , H_2SO_4 , H_2PO_4 , HClO_4 , H_2SeO_4 , H_2CO_3 , NH_4OH , KOH , HCl , LiCl), халькогенидов ряда элементов (As, Ge, P), нек-рых галогенидов и карбонатов. Многие из этих веществ составляют основу более сложных по составу стёкол. Среди однокомпонентных стёкол наиб. практич. значение имеет оксид SiO_2 , отличающийся непрозрачностью, хим. устойчивостью, стойкостью к перепадам темп-ры. Однако технология его изготовления сложна и необходимая темп-ра высока. Чтобы снизить её и придать стеклу нужные свойства, к SiO_2 добавляют др. оксиды, прежде всего щелочные и щелочноземельные. При этом темп-ра нагрева снижается на 200—300 °C. Роль таких добавок (модификаторов) в том, что они «разрыхляют» сетку хим. связей в SiO_2 .

Вещество в С. с. представляет собой твердотельную систему атомов и атомных групп, прени. с ковалентной связью между ними. Дифракц. методы исследования (рентгеновской структурный анализ, электромография, нейтроннография структурная) позволяют определить упорядоченность в расположении соседних атомов (ближний порядок; см. *Дальний и ближний порядок*). По углу зависимости интенсивности рассеяния строят кривые радиального распределения атомов. Расстояния между максимумами этой кривой соответствуют меж. атомным расстояниям, а площадь, ограниченная максимумами, даёт информацию о ср. числе атомов, находящихся на соответствующем расстоянии от данного.

Стёкла, как правило, вязкотонкие, хрупкие, имеют раковинистый излом при сколе. По оптич. свойствам обычно прозрачны (для видимых, ИК-УФ-, рентгеновского и γ-излучения). Локальные механич. напряжения и неоднородность структуры стекла часто обуславливают *двойное лучепреломление*. Практически все стёкла слабо люминесцируют. Для усиления этого эффекта в них добавляют активаторы — редкоземельные элементы, уран и др. Используя вспомогат. возбуждения большой мощности (лазачку) и подобранные активаторы, получают активную среду для генерации мощного когерентного излучения (см. *Необходимый лазер*). Стёкла, как правило, диамантны, примеси окислов редкоземельных металлов делают их парамагнитными. Из иск-рых стёкол спец. состава получают с и г ал д (материалы, состоящие из одной или нек. кристаллич. фаз, равномерно распределённых в стеклообразной фазе). По электр. свойствам большинство стёкол — диэлектрики (силикатные стёкла), но есть и полупроводники (см. *Аморфные и стеклообразные полупроводники*)

и металлы (см. *Аморфные металлы, Металлические стекла*).

Поватие С. с. обобщается на конденсиров. системы, в к-рых отсутствует пространственное упорядочение не в расположении атомов, а в ориентации спинов и спиновой плотности (*спиновые стёкла*), в ориентации и распределении электрич. дипольных и квадрупольных моментов и т. п. (см. *Стёкла*).

Лит.: А. П. и А. А. Химики стёкла, 2 изд., Л., 1974; Мотт Н., Дэвис Э., Электронные процессы в некристаллических веществах, пер. с англ., 2 изд., т. 1—2, М., 1982; А. Я. и В. Н. С., Магнитизм в стёклах, П. О. Я. и К. О. Я. и др. В. А., Физика линзирования в стёклах, Л., 1974; Ш. У. и М. М., О природе стекла, «Природа», 1986, № 9.

СТЕЛЛАТОР (от англ. stellar — звёздный) — замкнутая *магнитная ловушка*, в к-рой необходима для удержания плазмы конфигурация магн. поля создаётся токами, текущими вне плазменного объёма. С. представляет собой одну из разновидностей *тороидальных систем*, магн. поле к-рых характеризуется валичием тороидальных (в топологич. смысле) магн. поверхностей с вращат. преобразованием (сдвигом, поворотом) силовых линий. Впервые на возможность существования в магн. поле таких поверхностей указал И. Е. Тамм (1928) на примере кольца с током, помещённого в продольное тороидальное магн. поле. В этом случае силовые магн. линии представляют собой тороидальные спирали, навивающиеся вокруг осевой линии кольцевого тока и совершающие в ср. т оборотов по малому азимуту при л оборотах вдоль тора. Важной характеристикой С. является вращательное преобразование — величина, определяющая число оборотов по малому азимуту при одном обороте вдоль тора: $\mu = \pi/l$. Если μ есть число иррациональное, то магн. силовая линия не замыкается сама на себя, образуя при бегекомом движении вдоль тора некую магн. поверхность. В случае рациональных μ происходит вырождение магн. поверхностей — они состоят из множества силовых линий, замыкающих на себя после л оборотов вокруг тора. Вся магн. конфигурация представляет собой семейство вложенных друг в друга магн. поверхностей с осью, совпадающей с центром кольцевого тока.

Подобные магн. конфигурации получили практич. использование в связи с развитием работ по управляемому термоядерному синтезу с магн. удержанием плазмы. Магн. поле плазменного шнура и токовых явровидных, расположенных снаружи замкнутых магн. поверхностей, выдвинул Л. Спитцер (L. Spitzer); он же предложил название для таких систем — С. Т. е. тор в звёздного вещества.

Вращат. преобразование силовых линий приводит к компенсации тороидального дрейфа заряд. частиц, обеспечивая равновесие плазмы. Дрейфовые траектории большинства частиц плазмы (т. е. продольных) оказываются близкими к магн. поверхности и смещены на величину порядка $1/l$ (ρ — ларморовский радиус частицы). Переход с одной дрейфовой траектории на другую происходит лишь в результате столкновений с др. частицами. Исключением составляют частицы с малыми продольными скоростями, захваченные в локальных минимумах винтового и тороидального полей. Отклонение этих траекторий от магн. поверхностей существенно больше и именно этими частицами в случае редких столкновений в горячей плазме определяются коэф. диффузии и теплопроводности (неоклассич. теории переноса; см. *Перенос процессы*).

В классич. С. и тороидальному магн. полю добавляется магн. поле 2l винтовых оборотов с чередующимся направлением токов. Магн. поле внутри винтовых проводников не очень крупного тора описывается потенциалом

$$U = B_0^2 + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \epsilon_k / k(k\pi r) \sin k(\varphi - \alpha),$$

где B_T — тороидальное магн. поле, $e_k = B_{Lk}/B_T$ — относит. амплитуда винтовых гармоник, $\alpha = 2\pi/L$ (L — шаг винтовой обмотки) и r, φ, s — пространственные координаты, $I_k(z)$ — модифициров. ф-ция Бесселя. Внутри данного объема возникают два вида силовых

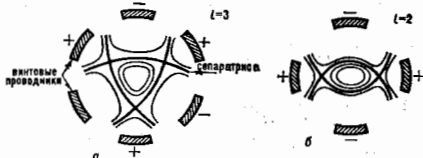
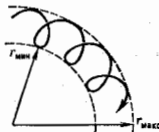


Рис. 1. Поперечное сечение магнитных поверхностей для стелларатора с $i = 3$ (а), с $i = 2$ (б).

вых линий: силовые линии, охватывающие винтовые проводники, и внутр. линии, образующие магн. поверхности. Поверхность, разделяющая обе эти

Рис. 2. Поперечная проекция силовой линии: $r_{\text{мин}}$ и $r_{\text{макс}}$ — минимальный и максимальный радиусы магнитных поверхностей.



области, наз. сепаратрисой. В пренебрежении тороидальности и вкладом более высоких гармоник она представляет собой l -угольную винтовую поверхность с шагом, равным шагу винтовой обмотки, и ребрами, расположенными напротив проводников с направлением

тока, противоположным направлению продольного поля B_z при правом винтовом обходе, и наоборот — при левом. Схематич. изображение поперечного сечения магн. поверхностей для C с $l = 3$ и $l = 2$ приведено на рис. 1. Силовые линии замкнутых магн. поверхностей отстают от вращения ребер сепаратрисы. Совершенная радиальные и азимутальные колебания, силовые линии дрейфуют по малому азимуту, обеспечивая ср. угол преобразования поворота. На рис. 2 изображена поперечная проекция силовой линии на нек-рой магн. поверхности.

Преобразование поворота в C возникает в результате усреднения вдоль тороидальной системы несмотря на то, что среднее полоидальное магн. поле $\langle B_{\theta} \rangle$ внутри винтовых проводников равно нулю, $\oint B_{\theta} dl = 0$. Подлоидальный магн. поток через продольную перегородку dS между бликами магн. поверхностей $d\Phi = \int B_{\theta} dS$ не равен нулю и соответственно вращает преобразованные μ численно равно $d\Phi/d\Phi$, где $d\Phi$ — продольный магн. поток, охватываемый данными поверхностями.

Др. характеристической магн. поля C является величина радиальной производной вращат. преобразования $d\theta/dr$, или т. н. впр $\theta = \mu' r/\mu$ (r — усредненный радиус сечения магн. поверхности), характеризующий степень перекрещенности силовых линий при переходе с одной поверхности на другую. Создание достаточной величины μ необходимо для обеспечения устойчивости плазмы в системе. Величина μ и θ характеризуют также степень топологич. устойчивости магн. структуры C . Для обеспечения заданной структуры поля необходимы высокая точность изготовления магн. обмоток C . Неизбежные неточности изготовления установки могут приводить к заметной деформации магн. поверхности. Особую опасность для удержания плазмы представляют резонансные возмущения рациональных магн. поверхностей с низкими значениями m и n , приводящие к образованию т. н. магн. островов (см. *Пересоединение магн. полей*), что равносильно уменьшению эффективного поперечного размера системы. Устойчивость плазмы в C может быть также обеспечена при низких значениях магн. шира при наличии ср. магн. ямы (см. *Стабилизация неустойчивостей плазмы*).

Магн. поле C может быть создано разл. способами. Система, где тороидальное и винтовое поля создаются винтовыми обмотками с одинаково направленными токами, наз. торсатроном. Гелиотрон — установка, в к-рой наряду с торсатронными обмотками используются катушки, создающие часть тороидального магн. потока. Магн. поле C может быть создано и без винтовых обмоток — с помощью специально

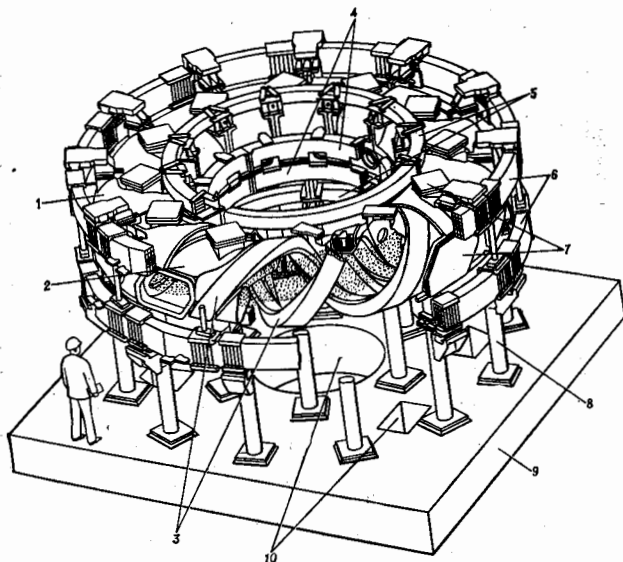


Рис. 3. Схема конструкции стелларатора — торсатрона АТР: 1 — металлическая оболочка; 2 — вакуумная камера; 3 — винтовые обмотки; 4 — внутренние обмотки поперечного поля; 5 — средние обмотки поперечного поля; 6 — внешние обмотки поперечного поля; 7 — фланец вакуумной камеры; 8 — опоры установки; 9 — основание; 10 — место для исследовательской аппаратуры.

профилированных катушек. Разрабатываются и более сложные системы с пространственной магн. осью.

Первые эксперим. исследования на С. (СПА, 1950—60-е гг.) были неудачны: на всех установках наблюдалась повышенная *Бома диффузия* плазмы. Причины неудач — относительно низкие значения поперечных магн. полей и отсутствие контроля за качеством магн. поверхностей. Успехи в СССР на установках типа *токамак* привели к закрытию амер. стеллараторной программы и переклону усилий на исследования на токамаках. В 1980-х гг. исследования по С. переместились в СССР, ФРГ, Великобританию и Японию. На С. Л-1 (ФИАН) впервые был разработан метод измерения структуры магн. поверхностей и показано, что диффузия плазмы, созданной внеш. инжекцией, примерно на порядок медленнее бомбовой. На С. «Вандельштейн-1» (ФРГ) было показано, что холодная ($T \approx 0,2$ эВ) деиевая плазма udržивается в С. классически. Исследования, проведенные во мн. лабораториях мира на небольших установках с относительно холодной и непотной плазмой, показали удовлетворит. удержание плазмы в С. В нач. 70-х гг. на установке «Ураган» (Харьков) был успешно проведен ионно-циклотронный *нагрев плазмы* и показано, что потери энергии по новому каналу близки к неоклассическим. В сер. 70-х гг. были введены в строй С. 2-го поколения: Л-2 (СССР), «Вандельштейн-VIIA» (ФРГ) и «Клео» (Великобритания), на к-рых при омч. нагреве была получена плазма плотностью $n_e = 10^{13}$ см $^{-3}$ и темп-рой $T_e \approx 0,5$ кэВ, лостунная равне только на токамаках. На С. «Вандельштейн-VIIA» была создана бестоковая плазма в режиме инжекции пучков нейтральных атомов; проводится исследование бестоковой плазмы, создаваемой методом электронного циклотронного резонанса и инжекции нейтральных пучков. В 80-х гг. были сооружены крупные установки «Гелиотрон-Е» (Япония), «Вандельштейн-VIIAS» (ФРГ), АТФ (СПА), на к-рых были достигнуты более высокие параметры плазмы: $T_e \leq 3$ кэВ (нагрев при электронном циклотронном резонансе), $n_e \leq 10^{14}$ см $^{-3}$ и $\beta_{\text{макс}} \approx 2-3\%$ (нейтральная инжекция). Гл. преимущество С. — возможность стационарной работы. В 1991 на С. АТФ было продемонстрировано удержание горячей плазмы в течение 20 с; проектируются С. «Вандельштейн-VIIХ» и «LHD» со сверхпроводящими магн. обмотками, работающими в стационарном режиме.

Лит.: Рабинович М. С. Экспериментальные исследования на стеллараторах, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Физика плазмы, т. 2, М., 1981, с. 6; Шафранов В. Д. Термоядерные системы для управления термоядерного синтеза, там же, т. 8, М., 1988, с. 131; Вольков Е. Д., Супруненко В. А., Шиншикин А. А., Стелларатор, К., 1983.

СТЕПАНОВА УНИВЕРСАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ — соотношение между спектрами поглощения и люминесценции сложных молекул, обобщающее разл. спектрально-энергетич. закономерности — правила Стокса и Вавилова — Ломмеля, принцип зеркальной симметрии и т. д. С. у. с. является аналогом *Кирхгофа закона излучения* и отражает свойства, общие для *теплового излучения и люминесценции*.

С. у. с. выполняется при условии равновесного распределения системы по колебат. подуровням возбужденного электронного уровня энергии сложной молекулы. Такое распределение устанавливается за времена $\sim 10^{-11} - 10^{-13}$ с, т. е. значительно меньше, чем времена жизни возбужденных состояний (не менее 10^{-9} с), и, следовательно, оно предшествует возникновению излучат. квантовых переходов. При выполнении всех необходимых условий мощность люминесценции ω , на данной частоте ν однозначно связана с коэф. поглощения света K_ν той же частоты:

$$\frac{\omega_\nu}{K_\nu} = \frac{8\pi h \nu^4}{c^2} \frac{n_1}{n} \exp(h\nu/kT) C(T),$$

где n_1 — число возбужденных молекул, n — общее число молекул системы, $h\nu$ — энергия кванта, соот-

ветствующего чисто электронному переходу, kT — тепловая энергия, а $C(T)$ — нормировочный множитель, учитывающий различие *статистических весов* основного и возбужденного уровней.

С. у. с. справедливо для всех систем, в к-рых распределение по колебат. подуровням возбужденного электронного уровня не зависит от способа возбуждения (в т. ч. и от частоты возбуждающего света). В системе, кроме того, должны отсутствовать примеси, поглощающие энергию возбуждения, но не люминесцирующие. С. у. с. экспериментально подтверждено для мн. сложных молекул в растворах и парах, а также для атомов, взаимодействие к-рых со средой отражается на форме контуров их линий поглощения и испускания. При этом положение максимума линии (или полосы) люминесценции никогда строго не совпадает с положением максимума линии (или полосы) поглощения, всегда несколько смещено от него в ДВ-область и имеет широкую форму.

Лит.: Степанов Б. И., Грябковски Я. В. П., Введение в теорию люминесценции, Минск, 1983. Ю. П. Тимофеев.

СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ ЧИСЛО в механике — число не зависящих между собой *возможных переменных* механич. системы. С. с. ч. зависит от числа материальных точек, образующих систему, и от числа и характера валентных на систему *связей механических*. Для свободной материальной точки С. с. ч. равно 3, для свободного твердого тела — 6, для тела, имеющего неподвижную ось вращения, С. с. ч. равно 1 и т. д. Для любой *гомономной системы* (системы с геом. и интегрируемыми дифференц. связями) С. с. ч. равно числу s независимых между собой координат, определяющих положение системы, и дается равенством $s = 3n - k$, где n — число точек системы, k — число геом. связей. Для *негомономной системы* (системы, на к-рую, кроме голономных, наложены ещё неголономные, т. е. *неинтегрируемые дифференц. связи*) С. с. ч. меньше числа координат, определяющих положение системы, на число неголономных связей. От С. с. ч. зависит число дифференц. ур-ний движения как условий равновесия механич. системы. С. М. Тарз.

СТЕПЕНИ СВОБОДЫ — независимые возможные изменения состояния (в частности, положения) физ. системы, обусловленные вариациями её параметров. В механике С. с. соответствуют независимым переменным механич. системы, число к-рых определяется числом образующих систему частиц и наложенных на неё механич. связей (см. *Степеней свободой число* в механике).

В *статистической физике* С. с. соответствуют независимым обобщенным координатам, определяющим полную энергию или *Гамильтона функция* системы. Число С. с. позволяет оценить *теплоемкость* многоатомных газов и твердых тел при высоких темп-рах, когда применима классич. статист. механика и энергия равномерно распределена на С. с. (*равнораспределенный закон*). Однако при обычных (комнатных) темп-рах не все С. с. вносят вклад в теплоемкость многоатомного газа, некоторые из них выключены («заморожены»), т. к. могут возбуждаться лишь при достаточно высоких темп-рах.

В *квантовой механике* С. с. соответствуют независимым координатам, к-рые определяют *гамильтоновы* системы. Непрерывные поля нельзя охарактеризовать конечным числом С. с.

В *термодинамике* С. с. — независимые термодинамич. параметры, определяющие состояние термодинамич. равновесия системы. Число С. с. f равновесия термодинамич. системы определяется *Гиббса правилом* $f = n - r + 2 \geq 0$, где n — число компонентов, r — число фаз. Д. Н. Зубарев.

СТЕРАДИАН (от греч. stereós — телесный, объёмный и radian) (ср, Sr) — единица телесного угла; 1 ср равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезаемому на ней поверхностью, площадью к-рой равна площади квадрата со стороной, равной величине радиусу

сферы. $1 \text{ ср} = 7,96 \cdot 10^{-10}$ полного телесного угла $\omega = 3,28 \times 10^9$ квадратного градуса.

СТЕРЕОБАЗИС (от греч. stereos — телесный, объемный и basis — основание) — расстояние между двумя точками, одновременное наблюдение из к-рых одного и того же объекта даёт *стереоскопическое изображение* этого объекта. Для человеческого зрения С. — расстояние между передними узловыми точками глаз (колеблется от 58 до 72 мм).

Для повышения остроты бинокулярного зрения при рассматривании, напр., удалённых предметов, или *стереопар*, применяются оптич. приборы (призмённые или зеркальные), искусственно увеличивающие главную С. (см. *Стереотруба*, *Стереоскоп*). С увеличением С. уменьшается глубина резко воспринимаемого пространства, но увеличивается острота зрения, поэтому С. выбирается с учётом оптич. сечения этих критериев.

Л. А. Рыжков.

СТЕРЕОПАРА — сочетание двух плоских частичных изображений одного и того же объекта, полученных с двух разных точек зрения или в двух цветах (см. *Анаглиф метод*). При рассматривании С. так, чтобы каждый глаз видел только одно из этих изображений, возникает объёмная (стереоскопич.) картина, воспроизводящая глубину реального объекта, — *стереоскопическое изображение*. С. используют для создания пространственных изображений объектов в стереокино, стереофотографии, при стереофотограмметрич. съёмке.

Л. А. Рыжков.

СТЕРЕОСКОП — бинокулярный оптич. прибор для раздельного наблюдения правым и левым глазом соответственно своего частичного изображения стереопары, обеспечивающий оптич. совмещение этих изображений для получения единого зрительного образа, обладающего стереоскопичностью (см. *Стереоскопическое изображение*). В зависимости от конструкции различают С. пельцелье, дитяовые, зеркальные и комбинированные.

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ — пространственное (объёмное) зрение, обуславливающее возникновение трёхмерного зрительного образа наблюдаемого объекта за счёт параллакса, отглядывания объекта с разных сторон в предметном пространстве. При бинокулярном наблюдении в предметном пространстве к-л. точки А (рис. 1) её изображения в правом

рующих точках сетчаток, к-рые соответственно в правом и левом глазу находятся на одинаковых расстояниях от центр. ямок (напр., дуга A_1B_1 равна дуге A_2B_2 и $A_1C_1 = A_2C_2$). Идентичные изображения, получаемые на корреспондирующих точках, всегда сливаются в единый образ. Изображения точек, расположенных ближе или дальше горизонтра, получаются на несоответственных точках сетчаток глаз, что является сигналом мозгу для ощущения разнородности этих точек предмета от глаз. В естеств. условиях при неровное взгляда на разнородные предметы горизонтра непрерывно перестраивается. Несовпадение (диспаратность) изображений разнородных точек предмета на сетчатках глаз тем больше, чем больше значение угл. параллакса фиксируемой точки А и одновременно наблюдаемых точек B' , C' и т. д. Значения разностей этих параллакса $\alpha - \beta$ или $\alpha - \gamma$ наз. дифференциальными угловыми параллаксами $\Delta\alpha$. Мин. диспаратность, к-рую человек способен ощутить, определяет величину предельного угла дифференц. параллакса $\Delta\alpha_0$ (остроту зрения). Эта величина является порогом стереосприятия, к-рый у разных лиц различен, но обычно не превосходит $30''$. От него зависит разрешающая способность восприятия изображения по глубине. Наим. величина Δr различия разнородности точек предмета определяется след. отношением:

$$\Delta r = \frac{r}{g} \Delta\alpha_0 (b_0 \pm r_0 \Delta\alpha_0),$$

где r_0 — удалённость от зрителя фиксируемой точки; b_0 — межзрачковый стереобазис у наблюдателя (≈ 65 мм); знак плюс в знаменателе относится к точкам, расположенным ближе фиксируемой, знак минус — к точкам, дальше фиксируемой.

На произвольном расстоянии r разрешающая сила S з. а. равна:

$$W(r) = 1/\Delta r \approx b_0/r^2 \Delta\alpha_0.$$

Если b_0 и r выражены в м, а $\Delta\alpha_0$ — в радианах, то $W(r)$ имеет размерность м^{-3} и определяет кол-во раздельно различимых планов на глубине пространства в 1 м, удалённого от наблюдателя на расстояние r . Так, при $\Delta\alpha_0 = 30''$ ($0,000145$ рад) и $b_0 = 65$ мм:

$$W(r) = 450/r^2 (\text{м}^{-3}).$$

Из этого выражения следует, что на расстоянии $r = 10$ м можно различить 4,5 глубинного плана на протяжённости 1 м, т. е. глубинное разрешение составляет 22 см, а на расстоянии $r = 2$ м разрешающая сила С. з. равна 112,5 планам/м и, следовательно, глубинное разрешение уже не превышает 0,9 см.

Объём информации, даваемой С. з., можно оценить кол-вом различных планов N на глубине рассматриваемого пространства на расстоянии от r_1 до r_2 , к-рый определяется как

$$|N|_{r_1}^{r_2} = \sum_{r_1}^{r_2} b_0 \Delta r / \Delta\alpha_0 r^2. \quad (1)$$

Заменив суммирование интегрированием, имеем

$$|N|_{r_1}^{r_2} = (b_0/\Delta\alpha_0)(1/r_1 - 1/r_2). \quad (2)$$

При наблюдении объекта через бинокулярные зрительные приборы или проекц. системы разрешающая сила С. з. растёт пропорционально действующему стереобазису B и эфф. увеличению оптическому прибору G :

$$W^*(r) = BG/\Delta\alpha_0 r^2.$$

Предельное расстояние, начиная с к-рого уже нельзя в естеств. условиях стереоскопически различить

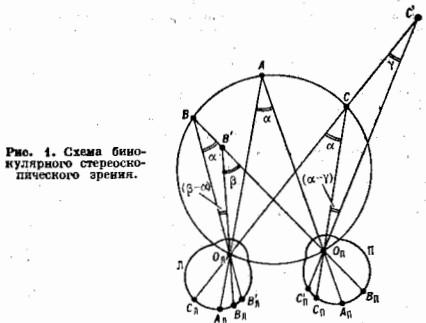


Рис. 1. Схема бинокулярного стереоскопического зрения.

удаленности объектов, наз. радиусом стереовидения, равным

$$r_{\infty} = b_0 / \Delta \alpha_0. \quad (3)$$

Для лиц, обладающих острой зрения в $30''$, $r_{\infty} \sim 450$ м.

Однако при наблюдении *стереоскопического изображения* зритель постоянно фиксирует взглядом плоскость совмещённой стереопары изображений (на экране), к-рая в этом случае представляется частью стационарного (неперестраиваемого) горнотера, в связи с этим r_{∞} ограничивается расстоянием:

$$r_{\infty}^* = b_0 (\omega_0 + d / r_0),$$

где ω_0 — предельный угол разрешения глаза, d — действующий диаметр зрачка глаза.

В этом случае глубинная протяжённость стереоскопически наблюдаемого образа ограничивается максимально допустимым углом, в пределах к-рого возможно сливание (фузии) наблюдаемых изображений стереопары. Этот угол ϕ наз. фузионным, его величина составляет $1,6^\circ - 2,0^\circ$. Границы глубины пространства, в к-ром может существовать слитый пространственный образ, зависят от расстояния рассматривания и удалены от экрана на расстояния $\Delta r_1 = \phi_0^* / (b_0 + \phi_0)$ перед экраном и $\Delta r_2 = \phi_0^* / (b_0 - \phi_0)$ за экраном (рис. 2). Из графика видно, что на более удалённых экранах

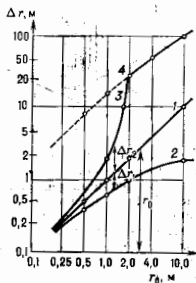


Рис. 2. Диапазон глубины стереоскопически реализуемого пространства относительно экрана и зависимости от расстояния наблюдателя до экрана: 1 — плоскость экрана; 2 — граница стереопрозрачности перед экраном; 3 — граница стереопрозрачности за экраном; 4 — радиус действия стереоскопа.

возможно реализовать более широкие по глубине зоны стереоскопич. видения. Так, на экране, удалённом от зрителя на 10 м, можно наблюдать протяжённость пространственного изображения в зоне от 1,8 до 90 м; при рассматривании стереофотографий с расстояния 25 см восприимчивое пространство ограничено лишь глубиной зоны ~ 6 м. Однако это не означает, что кол-во различимых по глубине планов на более удалённых экранах будет больше. Кол-во различных планов в данном случае может быть определено по соотношениям (1) и (2), в к-рых величина $\Delta \alpha_0$ должна быть заменена величиной ϵ , представляющей отношение величины разрешения зрачка к расстоянию его от зрителя.

При наблюдении пространства предметов движущимся наблюдателем (напр., из окна вагона) возникает динамический стереоэффект, обусловленный параллаксированием этого пространства. Динамич. стереоэффект проявляется и при монокулярном зрении; он основан на инерционности зрения: сливание при стереоскопич. изображении в зрительном аппарате человека возможно и при одновременном их возникновении через интервалы Δt , не превышающие время инерции зрения. Если, напр., наблюдатель движется слева направо, фиксируя взором предмет А, удалённый на расстояние r_A , и скорость его движения v , то за интервал времени Δt , равный времени инерции зрения, точ-

ка наблюдения переместится на величину базиса $B = v \Delta t$. Прямую, параллельную дуге следования наблюдателя и проходящую через точку А, можно наз. динамическим монокулярным горнотером — по аналогии с горнотером бикулярного зрения. При сливании за точкой А глаз поворачивается таким образом, что изображение точки А всё время находится на центр. ямке сетчатки. На своих местах сетчатке остаются и все изображения предметов, расположенные на горнотере. Однако изображения предметов, находящихся ближе и дальше горнотера, перемещаются по сетчатке. Благодаря этому наблюдателю кажется, что более близкие предметы перемещаются назад относительно точки А, а более удалённые предметы обгоняют точку А в направлении его движения. И вся видимая наблюдателем панорама представляется как бы вращающейся вокруг фиксируемой точки А по часовой стрелке (для направления движения наблюдателя слева направо). Пороговые величины различия глубины пространства в данном случае зависят от скорости перемещения наблюдателя и определяются соотношением,

$$\Delta r^{**} = r_A^2 (v \Delta t \pm r_A \Delta \alpha_0),$$

где знак плюс используется для порога глубины в сторону от точки А к наблюдателю, знак минус — в сторону за неё.

Радиус действия динамич. стереоэффекта r_{∞}^{**} аналогично (3) может быть определён величиной:

$$r_{\infty}^{**} = v \Delta t \alpha_0.$$

При больших скоростях движения наблюдателя, напр. при $v = 10$ м/с (36 км/ч), $\Delta t = 0,1$ с; $r_A = 0,0003$ (1 угл. мин), величина r_{∞}^{**} составляет 3300 м, намного превышая радиус бикулярного стереовосприятия.

Динамич. стереоэффект важен и для различения глубины пространства на близких расстояниях при малых скоростях перемещения точек зрения наблюдателя относительно объекта. (Примером этого является вращение нитки в ушко и иглки; боковое оглядывание иглки то одним, то другим глазом позволяет облегчить пространственное совмещение ушка с концом нитки.)

Лит.: Крайков С. В., Глаз и его работа, 4 изд., М., Д., 1950; Вальс Н. А., Стереоскопия, М., 1962; его же, Стерео-фотография, кино, телевидение, М., 1966; Логвинкин Ю. А. Д., Зрительное восприятие пространства, М., 1981.

СТЕРЕОКОПИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (пространственное изображение) — изображение предмета, к-рое представляется наблюдателю объёмным (трёхмерным), передающим форму изображаемых объектов, характер их поверхности, взаимное расположение в пространстве и др. вешн. признаки. Возникает С. и в сознании человека в результате сливания в единый зрительный образ двух плоских изображений *стереопары*, рассматриваемых раздельно каждым глазом.

Каждое из двух изображений стереопары представляет собой центр. проекцию объекта (полученную, напр., фотографированием) с правой и левой точек зрения, разнесённых по горизонтали на нек-рое расстояние, называемое *стереобазисом*. Изображение объекта, полученное с правой точки, должно рассматриваться правым глазом, а изображение, полученное с левой точки, — левым глазом. Простейшим прибором для такого рассматривания является *стереоскоп*. Т. к. правое и левое изображения стереопары представляют собой разные ракурсы объекта, то при оптич. наложении друг на друга они совмещаются не полностью, изображения равноудалённых точек объекта оказываются смещёнными вправо или влево относительно друг друга, образуя горизонтальный линейный параллакс. Величина параллакса зависит от удалённости наблюдаемой точки изображения. Если точка правого изображения в плоскости совмещения оказывается правее

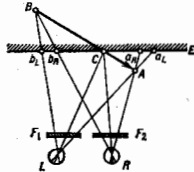
левого изображения этой точки, то параллакс считается положительным и пространственное положение слитного образа этой точки в С. и. будет представлять расположенным за плоскостью совмещения; если точка правого изображения расположена левее точки левого изображения, то параллакс считается отрицательным и слитное изображение точки оказывается перед плоскостью совмещения; при параллаксе, равном нулю, слитный образ формируется в плоскости совмещения.

Оптич. наложение правого и левого изображений стереопары друг на друга осуществляется селективной проекцией или печатью этих изображений, позволяющих в то же время посредством спец. фильтров выделять каждое изображение из их «смеси» для предъявления его предназначенному глазу. В зависимости от способов фильтрации изображений различают следующие способы воссоздания С. и.: очковые — анаглифический, поляризационный, аклисный; безочковые (растровые) — одностереопарные и микрорастровые.

Очковые методы наблюдения стереоскопического изображения

В анаглифическом методе воспроизведения С. и. (рис. 1) используются спектральная сепарация изображений стереопары. В этом случае одно из изображений стереопары, напр. правое $a_R b_R$, печатается

Рис. 1. Анаглифическая система синхронизация пространственного образа AB при рассмотрении на экране E изображений стереопары $a_R b_R$ и $a_L b_L$, соответственно правым R и левым L глазом через сепарирующие очки с цветными фильтрами F_1, F_2 .



на экране E красной краской, а левое изображение $a_L b_L$, налагаясь на красное, печатается зелёной краской. Тогда, рассматривая изображения через цветные очки, левым глазом L через красный светофильтр F_1 увидим тёмный силуэт зелёного изображения $a_L b_L$, а правым глазом R через зелёный светофильтр увидим тёмный силуэт только красного изображения $a_R b_R$. Слитный образ точек a_R и a_L , соответственно фиксируемых правым R и левым L глазом, будет виден на пересечении линий их визирувания в точке A перед экраном E . Аналогично визуальное слияние точек b_R и b_L , видимых правым и левым глазом, создаёт образ точки B , лежащей за экраном E . Т. е., точки A и B окажутся пространственно разнесены. Этот метод легко реализуется и широко используется для получения С. и. в полиграфии, кино, телевидении, однако он не позволяет воспроизводить цветные объёмные изображения (см. также Анаглиф метод).

Поляризационный метод может быть использован для проекц. воспроизведения цветных С. и. Левое и правое изображения стереопары проецируются на экран лучами поляризов. света с плоскостями поляризации, ориентированными взаимно перпендикулярно для правого и для левого изображений. В качестве экрана служат целлоляризуемые свет металлизированные поверхности или матированные прозрачные листы. Рассматривают изображения на экране через очки с поляризац. светофильтрами, при этом плоскости поляризации светофильтров, находящихся перед правым и левым глазом, ориентируют соответственно параллельно плоскостям поляризации лучей, проецирующих правое и левое изображения стереопары. Этот метод применяется для реализации стереокино.

Акклисный метод использует временную фильтрацию (поочередно рассматривание) правого и левого изображений стереопары. Правое и левое изображения в чередующемся порядке проецируются на экран

вместе с этим синхронно перед правым и левым глазом открываются и закрываются заслонки в очках, через к-рые зритель поочередно видит правым глазом правое изображение стереопары, левым глазом — левое изображение. Недостатком этого метода являются мерцания С. и., заметные при малой частоте (≤ 100 Гц) смены правых и левых кадров на экране. Однако и при малой частоте смены кадров (вплоть до единиц Гц) стереоэффект сохраняется, и поэтому метод находит применение в тех случаях, когда этим недостатком можно пренебречь, в частности в рентгенотехнике.

При решении практич. задач возможно комбинирование систем воспроизведения С. и. Такой симбиоз акклисного метода с поляризац. методом предложен для реализации стереоскопич. телевидения. В данном случае (рис. 2) на экране 2 телевизора 1 последовательно во времени экспонируются правые и левые изображения стереопары, а наблюдение С. и. ведётся через поляризац. очки 3 со взаимно перпендикулярно ориентированными плоскостями поляризации фильтров F_1 и F_2 . Перед экраном телевизора устанавливается управляемый транспарант, состоящий из листа поляридо-

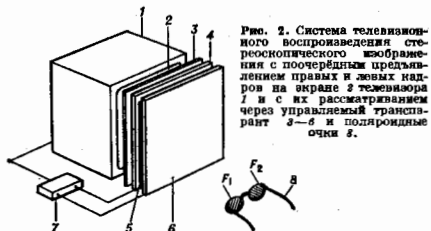


Рис. 2. Система телевизионного воспроизведения стереоскопического изображения с поочередным предъявлением правых и левых кадров на экране 2 телевизора 1 и с их рассматриванием через управляемый транспарант 3 — и поляридные очки 3.

3 и жидкокристаллич. модулятора света, выполненного из двух прозрачных проводящих пластин 4 и 6, между к-рыми расположен парафазный жидкокристаллич. слой 5. При подаче от коммутатора 7 электрич. управляющих импульсов к пластинам 4 и 6 происходит поворот плоскости поляризации лучей, проходящих через транспарант, на 90° то в одну, то в др. сторону. В те временные интервалы, когда та или иная фаза поляризации совпадает с экспозицией соответственно правых или левых кадров С. и. на экране телевизора, через поляридные фильтры F_1 и F_2 очком можно попеременно видеть правым глазом последовательность только правых кадров стереопары, а левым глазом — только левых кадров. Это обеспечивает зрительное восприятие пространственного образа С. и. на телевиз. экране.

Безочковые методы воспроизведения стереоскопического изображения

В таких методах для сепарации правого и левого изображений стереопары используют *растровые оптические системы*, создающие перед экраном зоны избират. видения, из к-рых правым и левым глазом можно увидеть раздельно соответствующие изображения стереопары. Этот принцип автостереоскопии и пояснен на рис. 3. Если перед фотопластинкой E укрепить щелевой растр F и с нек-рого расстояния из точки A , спроецировать через растр на фотопластинку одно из изображений стереопары, напр. левое, то после проявляющей пластинки можно будет увидеть это растрованное изображение (обозначенное на рис. чёрными точками), наблюдая через тот же растр из положений A_R, A_1, A_2 и т. д., лежащих на прямой YU . Области A_R, A_1, A_2, \dots можно назвать зонами избират. видения левого изображения. Одновременно с левым изображением стереопары можно качественно на фотоплёнке E правое изображение, проецируя его на



Рис. 3. Принцип автостереоскопического воспроизведения пространственных изображений через щелевой растр F.

точке B_0 , лежащей на прямой $Y-Y'$ и сдвинутой вправо от точки A_0 на величину межрастрового баиса. Элементы этого изображения, отмеченные на EE' белыми кружочками, будут видны соответственно из зон избират. видения правого изображения B_0, B_1, B_2, \dots . Наблюдать слитное С. и. в данном случае можно свободно на каждой паре зон A_0B_0, A_1B_1, A_2B_2 и т. д.

Пока автостереоскопич. изображения для большой аудитории может осуществляться с помощью радиального растрового стереоэкрана, называемого также перспективным (рис. 4). Особенностью стереоэкрана является то, что плоскость экрана E и плоскость щелевого растра F , расположенного

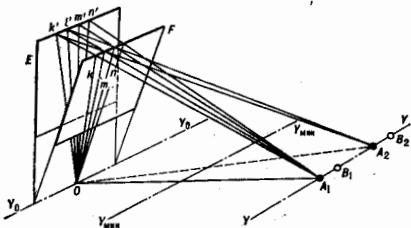


Рис. 4. Система проекционного воспроизведения стереоскопического изображения для бесочного (автостереоскопического) наблюдения пространственного изображения на радиальном растровом экране одновременно многими зрителями.

перед ним, наклонены друг к другу под небольшим углом, так что в своём продолжении они пересекаются по горизонтальной прямой Y_0Y_0' . Щели раstra направлены радиально к центру O , лежащему на прямой Y_0Y_0' . Если из какой-либо точки A_0 направить на экран E световой пучок, то свет, проходящий через щели растра k, l, m, n , образует на экране E картину полос k', l', m', n' , также радиально сходящихся к центру O . Световые плоскости, проходящие через щели растра, пересекаются по прямой OA_1 , из каждой точки k -рой можно увидеть через все щели освещённый экран, т. е. эта прямая представляет собой фокальную линию избирательного видения. Если период следования щели у растра в его сечениях, параллельных прямой Y_0Y_0' , постояен, то такими же линиями избират. видения являются и прямые OB_1, OB_2, OB_3, \dots , образуемые световыми лучами, отражёнными от освещённых полос экрана, напр. от полосы Ok' через соседние щели растра Ol, Om, On, \dots . Точки A_1, A_2, A_3 и др. располагаются на прямой $Y-Y'$, параллельной Y_0Y_0' и проходящей через точку A_0 .

Проецируя из др. точки B_1 , расположенной на прямой $Y-Y'$, на экран др. пучок света, можно создать новую серию линий избират. видения $OB_1, OB_2,$

OB_3 и т. д., расположенных в одной плоскости с линиями OA_1 . Все линии избират. видения образуют плоскость, называемую плоскостью избирательного видения.

Проецируя на экран из точки A_1 правое, а из точки B_1 левое изображение стереоизображения, можно создать в плоскости $OY-Y'$ условия для раздельного видения правого и левого изображений избирательно правым и левым глазом соответственно из зон OA_1 и OB_1 .

Очевидно, заменяя щели растра F цилиндрич. (конич.) линзами, можно сузить световые полосы от источника света на экране за растром и таким образом повысить разрешающую способность стереоэкрана. Благодаря этому на лизово-растровый стереоэкран с линией $Y-Y'$ можно проецировать не одну пару ракурсов (стереопару), а большое число ракурсов объекта, сфотографированных с горизонтального ряда точек (напр., точек 1, 2, 3, 4, ...), сдвинутых так, чтобы точка 2 была левее 1, точка 3 левее 2, точка 4 левее 3 и т. д. В этом случае в плоскости избират. видения $OY-Y'$ образуются смежно расположенные зоны, из любой пары k -рых можно наблюдать на экране С. и., рассматривая его в разных ракурсах.

Реализация такого рода многоракурсного С. и. возможна в разл. системах отображения визуальной информации, в частности на экране электронно-лучевой трубки прибора (рис. 5). Электронный проектор 1 проецирует через растр-решётку на люминесцентный экран E изображение объекта, видимое с левой точки; про-

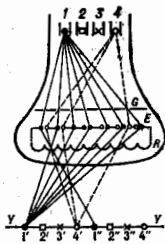


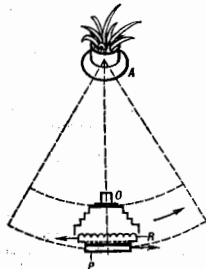
Рис. 5. Схема автостереоскопического формирования многоракурсного пространственного изображения на экране электронно-лучевой трубки, наблюдаемого через линзовый растр.

жектор 2 проецирует изображение, соответствующее правой точке; проектор 3 — ещё более правой точке; проектор 4 — крайней правой точке. Электронные лучи от каждого проектора, проходя через узкие щели решётки G , падают на разл. участки экрана E , вызывая свечение своего растрового изображения. Так, напр., лучи от проектора 1 вызывают свечение участков экрана, обозначенных на рис. 5 чёрными кружками, а от проектора 4 — освещёнными кружками. Установленный с др. стороны экрана линзовый растр R собирает излучение от точек экрана, освещённых проектором 1, в зону I' , от проектора 2 — в зону $2'$, проектора 3 — в зону $3'$, проектора 4 — в зону $4'$. Вдоль оси $Y-Y'$ образуются зоны избират. видения смежных ракурсов объекта, на любой паре

k -рых можно наблюдать пространственный образ объекта. Вдоль оси $Y-Y'$ образуются также допл. зоны избират. видения $I''-4'', I'''-4'''$ и др., позволяющие наблюдать С. и. одноврем. многими зрителями.

Подобный метод используется при изготовлении многоракурсных полиграфич. С. и., рассматривае-

Рис. 6. Панорамная съёмка параллельными многоракурсными стереоизображениями непрерывно движущейся фотокамеры на фотоматериал через линзовый растр.



ных через силесный с отпечатком лизовой растр. При этом объект фотографируют с разных сторон фотокамерой, движущейся вокруг него (рис. 8). Съёмка ведётся на фотоматериал P , прикрьтый лизовым растром K и, в свою очередь, сдвигаемый во время съёмки на величину периода (шага) лизового растра, для того чтобы распределить на фотоматериале раздельную запись последоват. ракурсов в виде кодированных лизоронок. (Совокупя т. н. параллелограмма, стереоскопическя считывается через декодирующий лизовый растр.)

Дальнейшим развитием многоракурсных С. и. является интегральная фотография, позволяющая записывать движение ракурсов объекта одновременно, как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном (см. *Растроные оптические системы*).

Наиб. сущест. отличие многоракурсных С. и. от одностереопарных является то, что первые создают более комфортные условия для наблюдения объёмного изображения и сохраняют жезаменимость пространственных соотношений картины при отнесит. перемещении наблюдателя, тогда как при наблюдении одностереопарного С. и. глубина и форма наблюдаемой картины меняются в зависимости от дистанции и местоположения наблюдателя.

Лит.: Вайсено В. И., Поляграфическое производство стереоизображений с лизовым растром, М., 1978; Мамчев Г. В., Стереослеждение, М., 1982; Валуев Н. А., Стерео: фотография, кино, телевидение, М., 1986; Дулинков Ю. А., Рогов В. Н., Расстояние системы для получения объёмных изображений, Д., 1986; Касс Б., Касс С. А., Практическая стереофотография, Минск, 1987. Н. А. Валуев.

Стереоскопическое изображение компьютерное. Появление персонального компьютера, снабжённого сканером и высококачеств. принтером (размер точки $1/300$ дюйма), позволило конструировать компьютерные стереокарточки и стереослайды (аналогичные обычным стереофотографиям и стереослайдам) и создавать объёмные компьютерные копии реальных объектов. Однако это возможно только в том случае, когда известна трёхмерная структура объекта или сцены, С. и. к-рых надо построить.

Примером объекта с известной структурой является любая макромолекула (молекула белка, нуклеиновой кислоты в т. п.), пространственная форма и размеры к-рой известны (обычно их находят методами рентгеновского структурного анализа). Для построения С. и. молекулу выбирают такую систему координат, начало отсчёта к-рой находится в центре тяжести молекулы (заранее найденном), ось X проходит горизонтально (параллельно прямой, соединяющей зрачки глаза наблюдателя), ось Z проходит вдоль направления наблюдения, а ось Y перпендикулярна им обеим. В этой системе отсчёта атом с координатами x, y, z будет виден левым глазом так, как если бы он находился в плоскости в точке с координатами

$$x_1 = (x-d)L/(L-z), \\ y_1 = yL/(L-z),$$

где L — расстояние до центра молекулы, d — расстояние между зрачками; соответственно для правого глаза:

$$x_2 = (x+d)L/(L-z).$$

Потому одним из вариантов построения стереопары на мониторе компьютера будет изображение левой и правой точек u_1, v_1 и u_2, v_2 :

$$u_1 = x_1 + R + m x_1, \\ u_2 = x_2 - R + m x_2, \\ v_1 = y_1 - m y_1,$$

где x_0, y_0 — координаты центра монитора, R — расстояние между правой и левой половинами стереопары, m — масштабный фактор, определяющий размер С. и.

Если построена последовательность компьютерных стереопар, то на мониторе компьютера можно наблюдать стереофильмы (невооружённым глазом либо с помощью стереоскопа).

Возможность построить стереопару по картине или рисунку художника зависит от того, использовались ли художником законы перспектив [1]. Если на рисунке, выполненном с использованием прямой перспективы, ясно видна точка перспектив, можно ввести предполагаемые пространственные координаты всех точек С. и. При построении стереопар пейзажа можно отл. объекты пейзажа внести в разные параллельные плоскости, в разл. степени удалённые от зрителя.

На рис. 7 приведена компьютерная стереопара, построенная по картине В. А. Серова «Ида Рубинштейн».

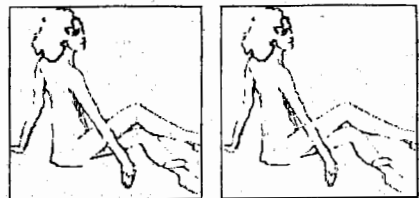


Рис. 7.

Построение С. и. невидимо. В окружающем мире имеется целый ряд измеремых, но не видимых человеческим глазом физ. величин, пространственное распределение к-рых часто необходимо знать в практич. целях. К таким величинам относятся, напр., интенсивность гамма-излучения естественных или техногенных радиоактивных веществ, абс. значения предельных атомных или молекулярных примесей в загрязнённом воздухе, воде и т. д., распределение темп., влажности воздуха и т. п. Компьютеры позволяют визуализировать измеренные величины, в частности построить для них условные С. и. Большое значение трёхмерная визуализация имеет в разл. мед. диагностиках, в частности в ЯМР-, рентгеновской и ультразвуковой томографии.

Восстановление трёхмерной сцены по стереопаре. Наряду с построением стереопар иногда необходимо решить обратную задачу — провести анализ оцифрованной фотостереопары для получения информации об изображённой на ней трёхмерной сцене [2]. Это бывает необходимо, напр., для дистанц. определения рельефа поверхности Земли или др. планет, морского дна, для автономной навигации передвижающегося робота. Осн. идея всех подходов к этой задаче — найти соответствующие (гомологичные) точки на левой и правой половинах стереопары и по расстоянию между этими точками определить локальную глубину данной точки в изображении сцены. Для решения этой задачи было предложено много алгоритмов [3]. Однако задача эта очень сложна и, по-видимому, ещё далека от решения: анализ стереопар предполагает наличие в памяти ЭВМ весьма обширных знаний о мире, без к-рых расшифровка стереопары в общем случае маловероятна.

При построении системы анализа стереопар очень важно уменьшить число элементов изображения — для облегчения нахождения соответствующих точек. Как правило, в прикладных задачах оказывается, что анализировать необходимо не всю информативную, содержащуюся в стереопаре, а лишь небольшую её часть. В ряде случаев, напр., особый интерес представляют сведения о прямых линиях, в частности о вертикаль-

ных прямых (это относится ко многим сооружениям — зданиям, заводам, улицам, дорогам и т. п.).

Если для восстановления трёхмерной структуры объекта для сцены по стереопаре нужно найти не слишком большое число гомологичных точек, то компьютер только помогает человеку, к-рый отмечает ряд важных пар точек-гомологов на фотостереопаре, выведенной на экран компьютера. Более подробно вопросы С. и. см. в [3].

Лит.: 1) Мочалов Л. В., Пространство мира и пространство картины, М., 1983; 2) П ол ж и о Т., Зрение человека и технические системы зрения, «В мире науки», 1984, № 6, с. 58; 3) Веденов А. А., Математика стереозображений, М., 1991.

СТЕРЕОТРУБА — бинокулярный стереоскопич. прибор, состоящий из двух зрительных труб на парвирной оси; обеспечивает получение стереоскопического изображения (изображение прямое, увеличение оптическое ~10—20). С. применяется в военном деле.

СТЕРЖЕНЬ в акустике — упругое твёрдое тело, длина к-рого значительно превышает его поперечные размеры. С. представляет собой важный элемент *линейной задержки* в *надежных акустоэлектронных*, используются в высокочастотных пьезоэлектрич. датчиках давления, различных музыкальных устройствах и инструментах (ксилофоне, камертоне). К задачам колебаний С. относятся мн. расчёты нагрузок строит. конструкций.

В С. могут распространяться продольные, крутильные и изгибные упругие волны. В отличие от волны в неограниченных твёрдых телах, волны в С. (т. в. *нормальные волны*) удовлетворяют не только ур-ниям теории упругости, но и граничным условиям на боковых и торцевых поверхностях С.

Продольные волны в С. — однородные по сечению деформации сжатия и растяжения, распространяющиеся вдоль оси С. Смещение u в низкочастотной продольной упругой волне, длина к-рой значительно превышает поперечные размеры С., удовлетворяет волновому ур-нию

$$\rho S \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} (ES \frac{\partial u}{\partial x}) = 0, \quad (1)$$

где ρ — плотность материала С., S — площадь поперечного сечения С., x — координата вдоль оси С., E — модуль Юнга. Возмущение, описываемое ур-нием (1), в случае постоянных по длине С. S и E распространяется без изменений со скоростью $c_{пр} = \sqrt{E/\rho}$. Высокочастотные продольные волны распространяются в С. как в неограниченном твёрдом теле со скоростью

$$c_{пр}^* = \sqrt{(1-\nu)E/(1+\nu)(1-2\nu)},$$

где ν — коэф. Пуассона. Для большинства материалов $c_{пр}^*$ незначительно превышает $c_{пр}$. В промежуточной области для волн, сравнимых с поперечными размерами С., наблюдается дисперсия.

Крутильные волны в С. соответствуют распространению симметричного относительно оси С. вращат. движения поперечного сечения. Ур-ние движения в этом случае для угла закручивания сечения С. $\varphi = \varphi(x, t)$ имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \frac{\mu}{\rho} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0,$$

где μ — модуль свдвига.

Скорость распространения крутильных волн не зависит от радиуса поперечного сечения, $c_{кр} = \sqrt{\mu/\rho}$. При изменении частоты скорость распространения крутильной волны не изменяется.

Изгибные волны в С. характеризуются смещением u точек оси С. в поперечном направлении, ур-ние для к-рых записывается в виде:

$$\rho I \frac{\partial^4 u}{\partial t^2 \partial x^4} = EI \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \rho S \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (2)$$

где I — момент инерции поперечного сечения С. относительно поперечной оси, лежащей в нейтральном сечении. В случае низкочастотных волновых движений пренебрегают членом в левой части ур-ния (2), учитывая инерционное сопротивление повороту сечений С., и получают решения, описывающие две диспергирующие волны, распространяющиеся в противоположных направлениях с фазовой скоростью

$$c_{изг} = \pm \sqrt{EI/\rho S} \cdot \sqrt{\omega}.$$

Групповая скорость низкочастотных изгибных волн в С. в два раза больше фазовой. При описании высокочастотных изгибных волн учитывают поворот сечений С. и пользуются строгим решением ур-ния (2). Высокочастотная изгибная волна в С. не испытывает дисперсии, скорость её распространения $c_{изг} = \sqrt{\mu/\rho}$. Вынужденные колебания С. под действием переменной вынуждающей силы происходят с частотой ω приложения. При прекращении действия вынуждающей силы ограниченный С. продолжает колебаться на нек-рых собств. частотах ω_n . Собств. частоты продольных колебаний С. не зависят от способа его закрепления и описываются ф-лой

$$\omega_n^{пр} = \sqrt{E/\rho} \cdot \pi n/l, \quad n=1, 2, \dots,$$

где l — длина С. Аналогичная ф-ла для частот собственных крутильных колебаний имеет вид:

$$\omega_n^{кр} = \sqrt{\mu/\rho} \cdot \pi n/l, \quad n=1, 2, \dots$$

Собств. частоты этих двух видов колебаний образуют гармонич. ряд. Собств. частоты изгибных колебаний С., $\omega_n^{изг}$ гармонич. ряда не образуют вследствие дисперсии. Напр., для случая закреплённого на концах С.

$$\omega_n^{изг} = \sqrt{EI/\rho S} \cdot 2.2n^2/l^3,$$

где $\alpha_1 = 4.73$; $\alpha_2 = 7.85, \dots$. Для случая свободных концов на концах С.

$$\omega_n^{изг} = \sqrt{EI/\rho S} \cdot (\pi n/l)^2, \quad n=1, 2, \dots$$

При совпадении частоты вынуждающей силы с одной из собств. частот С. имеет место резонанс.

Лит.: Красильников В. А., Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах, 3 изд., М., 1960; Тимошенко С. П., Свободные колебания систем, пер. с англ., М., 1971; С. В. Стефана.

СТЕФАНА — БОЛЬЦМАНА ЗАКОН ИЗЛУЧЕНИЯ — утверждает пропорциональность 4-й степени абс. темп-ры T полной объёмной плотности ρ равновесного излучения ($\rho = aT^4$, где a — постоянная) и связанной с ней полной испускат. способности σ ($\sigma = aT^4$, где σ — Стефана — Больцмана постоянная). Сформулирован на основе эксперим. данных И. Стефаном (J. Stefan, 1879) для испускат. способности любого тела. Однако последующие измерения показали его справедливость только для испускат. способности абсолютно чёрного тела. В 1884 С. — Б. з. и. был теоретически получен Л. Больцманом (L. Boltzmann) из термодинамич. соображений с учётом пропорциональности (согласно классич. электродинамике) давления равновесного излучения плотности его энергии. Однако значения постоянных a и σ оказалось возможным определить теоретически только на основе Планка закона излучения, из к-рого С. — Б. з. и. вытекает как следствие. С. — Б. з. и. применяют для измерения высоких темп-р.

М. А. Елькин, **СТЕФАНА — БОЛЬЦМАНА ПОСТОЯННАЯ** — фундаментальная физическая константа σ , входящая в закон, определяющий полную (по всем длинам волн излучения) испускат. способность абсолютно чёрного

мела (см. Стефан — Больцмана закон излучения); $\sigma = 5,89032(71) \cdot 10^{-8} \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^4)$.

СТИГМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (от греч. stigma, род. падеж stigmatos — точка, укол) — изображение оптическое, каждая точка к-рого соответствует одной точке изображаемого оптич. системой объекта. Строго говоря, подобное соответствие возможно лишь в идеальн. оптич. системах при условии, что устранены все aberrации (см. Aberrации оптические систем) и можно пренебречь волновыми свойствами света, в частности дифракцией света. Для реальн. и оптич. систем понятие С. з. является лишь приближением (вская реальная система изображает точку не точкой, а «пятном» или пространственной фигурой хотя и малых, но конечных размеров (см. Разрешающая способность)). Для параксиального пучка лучей ось aberrацией, нарушающей приближённую стигматичность изображения, является астigmatизм.

СТИЛОМЕТР (англ. steel — сталь и греч. metabo — измеряю) — спектральный прибор для экспрессного количественного эмиссионного спектрального анализа содержания элементов в сталях и цветных сплавах.

СТИЛЬБ (от греч. stílbō — сверкаю, сияю) (сб, sb) — единица яркости в системе единиц СГСЛ (см. г-с-люмен). $1 \text{ сб} = 10^4 \text{ кл/м}^2 = \pi \cdot 10^4 \text{ астильб} = \pi \text{ ланберт}$.

СТОК (St, St) — единица кинематич. вязкости в СГС системе единиц. Наив. в честь Дж. Г. Стокса (G. G. Stokes). $1 \text{ Ст} = 1 \text{ см}^2/\text{с} = 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}$. Обычно применяется сантосток: $1 \text{ сСт} = 10^{-2} \text{ Ст}$.

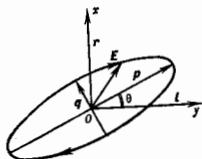
СТОКСА ЗАКОН — закон, определяющий силу сопротивления F , испытываемую твёрдым шаром при его медленном равномерном поступат. движении в неограниченной вязкой жидкости: $F = 6\pi\eta r v$, где η — коэф. вязкости жидкости, r — радиус шара, v — скорость его поступат. движения. Выведен Дж. Г. Стоксом (G. G. Stokes) в 1851. Этот случай обтекания шара часто наз. течением Стокса. С. з. справедлив лишь для малых Рейнольдса числа $Re \ll 1$. С помощью выражения $Re = \rho v r / \mu$, где ρ — плотность жидкости, С. з. преобразуется к безразмерному виду $C_x = 24/Re$, где C_x — аэродинамический коэффициент сопротивления, С. з. обобщается на случай нестационарного движения шара со скоростью $u(t)$, где t — время. В частности, для мгновенного (импульсного) приведения шара в поступат. движение со скоростью u_0 из состояния покоя С. з. принимает вид

$$F = 6\pi\eta r u_0 [1 + (\rho u_0^2 / \eta u t)^{1/2}].$$

С. з. используется в коллоидной химии, молекулярной физике, метеорологии. По С. з. можно определить скорость осаждения мелких капель тумана, коллоидных частиц, частиц ила и др. мелких частиц. Предельную скорость $v_{пр}$ падения шарика мелких размеров в вязкой жидкости находит по Фле $v_{пр} = \frac{2}{9} g (r^2 (\rho' - \rho) / \mu)$, где ρ' — плотность вещества шарика, g — ускорение свободного падения. С. з. применяют также для определения коэф. вязкости очень вязких жидкостей (см. Вискозиметрия). С. Л. Вышневецкий.

СТОКСА ПАРАМЕТРЫ — параметры, используемые для описания состояния поляризации эл.-магн. волн. Введены Дж. Г. Стоксом (G. G. Stokes) в 1852.

Идеальная плоская монохроматич. волна в общем случае поляризована эллиптически. Состояние её поляризации обычно описывают, задавая направление колебаний электрич. поля. Если волна распространяется перпендикулярно плоскости рисунка в направлении от нас (ось Oz), α — угол между большой осью эллипса и осью Oy , r — единичный вектор по оси Oz , I — единичный вектор по



оси Oy , то электрич. поле волны можно записать в виде $E = E_r e^{i\omega t} + E_i e^{i\omega t}$, где E_r и E_i — комплексные амплитуды, $E_r = A e^{i\alpha} \exp[i(\omega t - kz - \epsilon_r)]$, $E_i = a e^{i\alpha} \exp[i(\omega t - kz - \epsilon_i)]$. Здесь a и A — амплитуды соответствующих колебаний, α и ϵ_i — их фазовые сдвиги. Реально измеряются величины a_r, a_i и $\delta = \epsilon_i - \epsilon_r$ — разность фаз колебаний по осям I и r . Вдоль большой и малой осей эллипса введём единичные векторы p и q и представим поле E в виде:

$$E = a \cos \beta \sin \varphi \cdot p + a \sin \beta \cos \varphi \cdot q,$$

где $\varphi = \omega t - kz + \zeta$, ζ — фазовый угол, $|\cos \beta|$ и $|\sin \beta|$ — длины большой и малой осей эллипса, величина a^2 характеризует интенсивность пучка. Отношение осей эллипса — степень эллиптичности пучка — задается $|\tan \beta|$. Описать эллиптически поляризованную волну можно с помощью разл. групп четырёх параметров. Это либо $Re E_r, Im E_r, Re E_i, Im E_i$, либо $a_r, a_i, \epsilon_r, \epsilon_i$, либо $\alpha, \beta, \zeta, \delta$; каждая из этих групп легко выражается через другую.

Однако использование любой группы параметров для характеристики поляризации излучения неудобно, в частности трудности возникают при сложении пучков. Состояние поляризации светового пучка удобно описывать с помощью С. п., к-рые определяются ф-лами

$$S_1 = E_r E_r^* + E_i E_i^*, S_2 = E_r E_i^* - E_i E_r^*,$$

$$S_3 = E_i E_r^* + E_r E_i^*, S_4 = i(E_i E_r^* - E_r E_i^*).$$

С. п. представляют собой столбец-вектор:

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{bmatrix}$$

С. п. можно записать также в виде строки $[S_1 S_2 S_3 S_4]$. С точностью до пост. множителя эти величины имеют размерности интенсивности света, т. е. подобны *Полтинья вектору*. С. п. содержит полную информацию об интенсивности, степени и форме поляризации пучка. Для плоской волны С. п. легко представить через геом. характеристики:

$$S_1 = a_1^2 + a_2^2 = a^2, S_2 = a_1^2 - a_2^2 = a^2 \cos 2\beta \cos 2\theta,$$

$$S_3 = 2a_1 a_2 \cos \delta = a^2 \cos 2\beta \sin 2\theta,$$

$$S_4 = 2a_1 a_2 \sin \delta = a^2 \sin 2\beta.$$

В этом случае независимыми параметрами только три, т. к. $S_1^2 = S_2^2 + S_3^2 + S_4^2$. С помощью предыдущих ф-л по С. п. плоской волны легко определять величины, задающие направление колебаний E по осям I и r или q и p , т. е. восстановить поле.

Реальный световой пучок представляет собой суперпозицию огромного числа независимых мод поля излучения, быстро сменяющихся друг друга со случайными фазами и направлениями колебаний. С. п. суммарного пучка равны суммам С. п. отд. пучков:

$$S_1 = \sum_i S_{1i}, S_2 = \sum_i S_{2i}, S_3 = \sum_i S_{3i}, S_4 = \sum_i S_{4i}.$$

Это свойство С. п. используется в оптике. Первый С. п. — это интенсивность света. Часто применяются нормированные С. п., $S_i' = S_i/S_1$, т. к. они безразмерные величины (1, S_2'/S_1 , S_3'/S_1 , S_4'/S_1). Если $a_r = 0$, то свет поляризован горизонтально и его нормированные С. п. равны $(1, 1, 0, 0)$. Если $a_i = 0$, α и $\delta = 0$, свет поляризован под углом 45° (1, 0, 1, 0) и т. д. Для неполяризов. света $S_2 = S_3 = S_4 = 0$. Все параметры реального

пучка нетрудно определить с помощью анализатора и четвертьволновой пластины. Существуют уже составные С. п. для разных форм поляризации света [3].

При любом линейном отщ. процессе (рассеянии, отражении, преломлении на к.-л. поверхности) С. п. падающего пучка (S_0) линейно преобразуются в С. п. вышедшего пучка S_1 с помощью *Мюллера матрицы* M_{ik} : $S_i = M_{ik} S_{0k}$.

Лит.: 1) Розенберг Г. В., Вектор-параметр Стокса, УФН, 1955, т. 58, с. 77; 2) Холст Г., Рассеяние света малыми частицами, пер. с англ., М., 1961; 3) Шерлифф У., Поляризованный свет, пер. с англ., М., 1965; 4) Шифрин К. С., Введение в оптику океана, Л., 1963; 5) И. С. Шифрин, **СТОКСА ПРАВИЛО** — эмпирич. правило, согласно к-рому длина волны фотомикроскопическим должна быть больше, чем длина волны возбуждающего её отщ. излучения. Впервые установлено Дж. Г. Стоксом (G. G. Stokes) в 1852; впоследствии обобщено и уточнено Э. Ломмелем (E. Lommel) и С. И. Вавиловым. Согласно обобщённой С. п., максимумы (или центры тяжести) электронной полосы люминесценции сдвинуты в ДВ-область относительно максимума полосы возбуждения (стоксова люминесценция). С. п. обусловлено частичной потерей энергии электронного возбуждения центров свечения на возбуждение тепловых колебаний, происходящее между процессами поглощения и испускания света. Нек-рая (обычно небольшая) часть излучат. переходов может происходить и с участием квантов, более короткопериодных, чем возбуждающие. Такие процессы происходят с использованием тепловой энергии люминофора, однако вероятность переходов при этом невелика и интенсивность такой антистоксовой люминесценции обычно мала.

Лит. см. при ст. Люминесценция. Ю. П. Тимофеев, **СТОКСА ТЕОРЕМА** — обобщение Стокса формулы, утверждение о равенстве интеграла от внеш. дифференциала dw дифференциальной формы по ориентированному кумпактному многообразию M интегралу от самой формы по ориентированному (согласованно с ориентацией многообразия M) краю ∂M многообразия M :

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega. \quad (*)$$

Широко известными частными случаями (*) являются Гаусса — Остроградского формула, Грина формулы. **СТОКСА ФОРМУЛА** — одна из осн. интегральных теорем векторного анализа, связывающая поверхностный интеграл с криволинейным:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{a} d\mathbf{r} = \int_S (\text{rot } \mathbf{a})_n dS. \quad (*)$$

Здесь ∂S — замкнутая кривая, ограничивающая поверхность S , $(\text{rot } \mathbf{a})_n$ — проекция на внеш. нормаль к поверхности. Согласно С. ф., циркуляция векторного поля \mathbf{a} вдоль любой замкнутой кривой (левая часть равенства) равна потоку поля \mathbf{a} через поверхность, опирающуюся на эту кривую. Из С. ф. следует, что циркуляция безвихревого поля (т. е. такого, что $\text{rot } \mathbf{a} \equiv 0$) вдоль любой замкнутой кривой равна 0. С. ф. и Гаусса — Остроградского формула являются частными случаями Стокса теорем, к-рая связывает между собой интегралы от внешних дифференциальных форм разных размерностей. М. В. Менделеев, **СТОЛКНОВЕНИЙ ТЕОРИЯ** — см. в ст. Рассеяние микрочастиц.

СТОЛКНОВЕНИЯ АТОМНЫЕ — элементарные акты соударения двух атомных частиц (атомов, молекул, электронов или ионов). С. а. делятся на упругие и неупругие.

При упругом С. а. суммарная кинетич. энергия соударяющихся частиц остаётся прежней — она лишь перераспределяется между частцами, а направления движения частиц меняются. В неупругом С. а.

изменяются внутр. энергии сталкивающихся частиц (они переходят на др. уровни энергии) и соответственно изменяется их полная кинетич. энергия. При этом меняется электронное состояние атома либо колеблет. или вращат. состояние молекулы (см. Молекулярные спектры).

Упругие С. а. в газах или слабоионизов. плазме определяются переноса процессами. Испытываемые частицами С. а. — акты рассеяния на др. частцах — препятствуют их свободному движению. Наб. существование на перемещение частицы влияют те С. а., в к-рых направлении её движения заметно меняется. Поэтому коэф. диффузии (перенос частиц), вязкости (перенос импульса), теплопроводности (перенос энергии) и др. коэф. переноса газа выражаются через эфф. сечение рассеяния атомов или молекул этого газа на большие углы. Аналогично подвижность ионов связана с сечением рассеяния иона на атоме или молекуле газа на большие углы, а подвижность электронов в газе или электропроводность слабоионизов. плазмы — с сечением рассеяния электрона на атоме или молекуле газа.

Сечение упругого столкновения атомов или молекул на большой угол при тепловых энергиях частиц наз. газовой и естественным сечением; оно имеет величину порядка 10^{-18} см² и определяет длину свободного пробега частицы в среде.

Упругие С. а. на малые углы может влиять на характер переноса эл.-магн. излучения в газе. Энергия проходящей через газ эл.-магн. волны поглощается и затем нерезлучается атомами или молекулами газа. При этом даже слабое взаимодействие излучающей частицы с другими (окружающими её) частицами «исканяет» испускаемую волну, т. е. сдвигает её фазу или частоту. При нек-рых условиях осн. характеристики расширяющейся в газе эл.-магн. волны определяются упругим рассеянием взаимодействующих с ней атомов или молекул на окружающих частцах, причём существенным оказывается рассеяние на малые углы.

Процессы неупругих С. а. весьма разнообразны. Перечень неупругих процессов, к-рые могут происходить в газе или слабоионизов. плазме, приведён в табл.

Неупругие процессы столкновений с участием атомных частиц и фотонов

Пункты	Тип атомного столкновения	Схема процесса
1.	Ионизация при столкновении атомов и молекул	$A+B \rightarrow A+B^++e$
2.	Переход между электронными состояниями	$A+B \rightarrow A+B^* \rightarrow B^++B^+$
3.	Переход между колебательными или вращательными состояниями молекул	$AB(v)+C \rightarrow AB(v^*)+C \rightarrow AB(v^*)+e+AB(v)$ $AB(J)+C \rightarrow AB(J^*)+C \rightarrow AB(J^*)+e+AB(J)$ (v — колебательное квантовое число, J — вращательное квантовое число)
4.	Хим. реакции	$A+B \rightarrow AB+C$ $A+B \rightarrow AC+B$
5.	Тушение электронного возбуждения	$B^*+AC(v) \rightarrow B+AC(v^*)$
6.	Передача возбуждения	$A+B^* \rightarrow A^*+B$
7.	Спиновый обмен (при сохранении проекции полного спина атомов изменяется проекция спина у каждого из них)	
8.	Деполяризация атома (изменяется направление орбитального момента одного из сталкивающихся атомов)	
9.	Переходы между состояниями тонкой и сверхтонкой структуры одного из сталкивающихся атомов или молекул	

СТОНЕРА КРИТЕРИЯ ФЕРРОМАГНЕТИЗМА — условие возникновения ферромагн. состояния в модели коллективизирован. носителей магн. момента (см. Зончый магнетизм). В парамагн. состоянии число n_e электронов (на один атом) со спином, направленным вдоль направления намагнитченности, совпадает с числом n электронов со спином, направленным против намагнитченности:

$$n_e = n - n/2$$

(n — общее число электронов, проходящих на один атом). В рамках Стонера модели при тем-ре $T = 0$ энергетич. подзоны электронов с противоположно направленными спинами в результате обменного взаимодействия раздвигаются на величину 2Δ , пропорциональную намагнитченности, что приводит к увеличению числа электронов в подзоне с направлением спина против намагнитченности (см. рис. (б, в), в ст. Стонера модель; при $T = 0$ км. потенциал $\mu = \epsilon_F$, где ϵ_F — ферми-энергия). При этом произойдет изменение кинетич. энергии (в расчёте на один атом) на величину

$$\delta \epsilon_{\text{кин}} = \Delta(n_e - n_-)/2 = \Delta mn/2,$$

где m — относит. намагнитченность, $m = (n_+ - n_-)/n$. Предполагается, что величина Δ мала и можно ограничиться линейными по Δ членами. Изменение магн. энергии (в расчёте на один атом) при переходе на парамагн. состояние в ферромагнитное равно:

$$\delta \epsilon_{\text{маг}} = U n_+ n_- - (1/4) U n^2 = (1/4) U n^2 m^2,$$

где U — параметр обменного взаимодействия. В первом порядке по параметру Δ выполняется равенство

$$\rho(\epsilon_F) \Delta = (n_+ - n_-)/2 = mn/2.$$

Здесь $\rho(\epsilon_F)$ — значение плотности электронных состояний при энергии $\epsilon = \epsilon_F$. Полное изменение энергии равно:

$$\delta \epsilon = \frac{n^2 m^2}{4\rho(\epsilon_F)} [1 - U\rho(\epsilon_F)].$$

Если выполняется неравенство $U\rho(\epsilon_F) < 1$, то состоянию с нам. энергией будет соответствовать $m = 0$ и система окажется в парамагн. состоянии. В противном случае,

$$U\rho(\epsilon_F) > 1, \quad (1)$$

минимуму энергии будет соответствовать ферромагн. состояние $m \neq 0$. Это условие наз. С. к. ф.

При наличии внеш. магн. поля полное изменение энергии, учитывающее зеemannовское слагеоме, имеет вид:

$$\delta \epsilon = \frac{n^2 m^2}{4\rho(\epsilon_F)} [1 - U\rho(\epsilon_F)] - mn\mu_B H.$$

Равновесное состояние системы соответствует условию $d(\delta \epsilon)/dm = 0$, так что магн. восприимчивость (в расчёте на атом) имеет вид:

$$\chi = mn\mu_B/H = \chi_0(1 - \alpha)\chi_0, \quad (2)$$

где $\chi_0 = 2\mu_B\rho(\epsilon_F)$, $\alpha = U/2\mu_B^2 \Phi$. Ф-ла (2) описывает т. н. обменное усиление или спинового магн. восприимчивости при $T \rightarrow 0$ (χ_0 — значение магн. восприимчивости для системы независимых электронов, χ — при учёте обменного взаимодействия в среднем поля приближении или в рамках теории ферми-жидкости; подробнее см. Паули парамагнетизм). С помощью (2) С. к. ф. (1) может быть записан в виде $\alpha\chi_0 \geq 1$, выражающем условие неустойчивости парамагн. состояния ($\chi \leq 0$) и допускающем разл. обобщения (напр., в коэф. α могут быть учтены не только обменные, но также корреляционные и спин-флуктуационные эффекты).

Пункты	Тип атомного столкновения	Схема процесса
10.	Ионизация атома или молекулы электронным ударом	$e + A \rightarrow 2e + A^+$
11.	Диссоциация молекулы электронным ударом	$e + AB \rightarrow e + A + B$
12.	Ремобинация при тройных соударениях	$e + A^+ + B(e) \rightarrow A + B(e)$
13.	Диссоциативная ремобинация	$e + AB^+ \rightarrow A + B$
14.	Диссоциативное ярвление электрона к молекуле	$e + AB \rightarrow A^+ + B$
15.	Приращение энергии к молекуле при тройных соударениях	$e + A + B \rightarrow A^+ + B$
16.	Ассоциативная ионизация	$A + B \rightarrow A^+ + B^- + e$
17.	Эффект Пеннинга (атом A^* находится в метастабильном состоянии, причём энергия его возбуждения превышает энергию ионизации атома В)	$A^* + B \rightarrow A + B^+ + e$
18.	Взаимная нейтрализация ионов	$A^+ + B^- \rightarrow A + B$
19.	Переарядка ионов	$A^+ + B^+ \rightarrow A^{2+} + B$
20.	Ион-молекулярные реакции	$A^+ + BC \rightarrow AB^+ + C$ $A^+ + BC \rightarrow AB + C^+$
21.	Разрушение отрицательного иона	$A^- + B \rightarrow A + B + e$
22.	Превращение атомных ионов в молекулярные	$A^+ + B^+ \rightarrow A + B + e$
23.	Фотообразование атома или молекулы (с последующим спонтанным излучением возбужденного атома)	$h\nu + B \rightarrow B^* + e$
24.	Фоторемобинация и фотодиссоциация	$e + A^+ \rightleftharpoons A + h\nu$
25.	Фотодиссоциация и фоторемобинация атомов и радикалов	$h\nu + AB \rightleftharpoons A + B$
26.	Радикальное приращение электрона к атому	$e + A \rightarrow A^- + h\nu$

Примечание: А, В и С обозначают атом или молекулу; В⁻ — электронно-возбужденный атом или молекулу, e — электрон; А⁺, В⁺ — положительно заряженный ион, А⁻ — отрицательно заряженный ион; hν — фотон. Стрелки указывают направление процесса.

В лаб. условиях и разл. явлениях природы гл. роль играют те или иные отдельные неупругие процессы соударения частиц. Напр., излучение с поверхности Солнца обусловлено б. ч. столкновениями между электронами и атомами водорода, при к-рых образуются отрицат. ионы водорода (табл., п. 26). Осн. процесс, обеспечивающий работу гелий-неонового лазера (см. Газовый лазер), — передача возбуждения атомами гелия, находящимися в метастабильных состояниях, атомам неона (табл., п. 6); осн. процесс в электроразрядных молекулярных газовых лазерах — возбуждение колебат. уровней молекул электронным ударом (табл., п. 3), в результате этого процесса электр. энергия газового разряда частично преобразуется в энергию лазерного излучения. Осн. процессы в газоразрядных источниках света — возбуждение атомов электронными ударами (табл., п. 2) в резонансных лампах, а в лампах высокого давления — фоторемобинация электронов и ионов (табл., п. 24). Сигн. обмен (табл., п. 7) ограничивает параметры квантовых стандартов частоты, работающих на переходах между состояниями сверхтонкой структуры атома водорода или атомов щелочных металлов (табл., п. 9). Разл. неупругие процессы С. а. с участием свободных радикалов, ионов, электронов и возбужденных атомов определяют многие свойства атмосферы Земли, причём на равных высотах преобладают разл. процессы.

Лит.: Мак-Даннел И., Процессы столкновений в ионизованном газе, пер. с англ., М., 1987; Смирнов В. М., Атомные столкновения и элементные процессы в плазме, М., 1988; его же, Ионы и возбужденные атомы в плазме, М., 1974; Никитин Е. Е., Уманский Я. С. Я., Неадиабатические переходы при межлентных атомных столкновениях, М., 1979; Никитин Е. Е., Смирнов В. М., Меленевые атомные столкновения, М., 1990.

СТОЛКНОВИТЕЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИЯ — ионизация нейтральной частицы при соударениях с электронами, ионами, атомами. Подробнее см. Ионизация.

С. к. ф. указывает на благоприятные условия для возникновения магн. упорядочения при больших величинах параметра обменного взаимодействия U и при больших значениях $\rho(\mathcal{E}_F)$. Он показывает, почему магн. упорядочение возникает в группе 3d-металлов (металлы с незаполненной 3d-оболочкой). В периодич. таблице Менделеева в ряду переходных металлов (слева направо) число электронов возрастает, что приводит к увеличению \mathcal{E}_F , а также к росту $\rho(\mathcal{E}_F)$. С др. стороны, в столбце (сверху вниз) из-за роста общего числа электронов возрастает экранировка потенциала кулоновского взаимодействия, т. е. величина U уменьшается. В итоге, согласно С. к. ф., в ряду 3d-металлов вероятность ферромагнетизма зонных электронов должна уменьшаться слева направо. Т. к. модель Стонера неизвариантна относительно вращений, С. к. ф. оказывается завязан в пользу ферромагн. состояния из-за того, что существование выделенной оси сильно ограничивает спектр возмущений, а следовательно, и энергию системы.

Дальнейшее обобщение С. к. ф. (интеграл заз. также обобщенным критерием Стонера — Хаббарда) возникает при переносе выражения (2) на случай неоднородной статической восприимчивости $\chi(q)$, q — волновой вектор. Если томология ферми-поверхности допускает максимум $\chi_0(q)$ при $q \neq 0$, то обобщенный С. к. ф. $\chi_0(q) \geq 1$ может оказывать неустойчивость системы электронов относительно перехода из однородного парамагн. состояния в неоднородное антиферромагн. (в обоих состояниях усредненный магн. момент равен нулю). В металлах, где поверхность Ферми обладает свойством нести нга (имеются контурные участки при трансляции на вектор Q , напр. в одномерном случае $Q = 2k_F$, где k_F — ферми-импульс), $\chi_0(q)$ при $q = Q$ имеет логарифмич. особенность, $\chi_0(Q) \sim \chi_0(0) \ln(\mathcal{E}_F/T)$ при $T \rightarrow 0$. Тогда обобщенный С. к. ф. выполняется при столь уходящем малом значении α , что указывает на абсолютную неустойчивость парамагн. состояния относительно возникновения *слабой плотности волн*. Тот же эффект, описываемый с помощью обобщенного С. к. ф. для электронной поляризуемости, проявляется в неустойчивости системы электронов относительно возникновения *волн зарядовой плотности* при учёте наряду с прямыми кулоновскими и обменными также и электрон-фононного взаимодействия.

Литт. см. при ст. Стонера модель.

А. В. Веделев, О. А. Котляшкова.

СТОНЕРА МОДЕЛЬ — простейшая модель, описывающая возникновение ферромагн. упорядочения в переходных металлах, их сплавах и соединениях в рамках зонного магнетизма. С. м. представляет систему коллективизированных электронов металл. магнетика в виде идеального газа *боложеских электронов* (предполагается, что стационарные состояния этих систем совпадают). Эфф. самальтомикан этой системы $\mathcal{H} =$

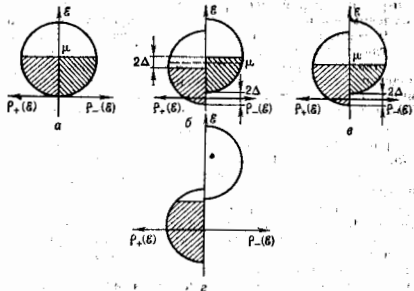
$$= \sum_{k, \sigma} \epsilon_{k\sigma} a^\dagger_k \sigma a_k \sigma, \text{ где } \epsilon_{k\sigma} = \text{энергия электрона в одно-}$$

частичном приближении, $a^\dagger_k \sigma$ ($a_k \sigma$ — оператор рождения (уничтожения) электрона с импульсом k , значением $\sigma = \pm 1$ соответствуют направлениям магн. момента вдоль (+) и против (-) намагнитченности (ось Oz)). В отличие от немагн. металлов, энергия $\epsilon_{k\sigma}$ учитывает межэлектронное обменное взаимодействие и в С. м. записывается в виде [1-3]:

$$\epsilon_{k\sigma} = t(k) - \sigma \Delta, \quad (1)$$

$$\Delta = \theta t m + \mu H. \quad (2)$$

Здесь $t(k)$ — закон дисперсии невазимодействующих электронов. Расщепление зоны электронов определяется величиной 2Δ (рис.), H — напряжённость магн. поля, $t = m(H, T) = M(H, T)/nN\mu_B$ — относит. намагнитченность, $M(H, T)$ — намагнитченность системы, содержащей N атомов и n коллективизированных электронов



Обменное расщепление подзон с направлением магнитного момента вдоль (+) и против (-) намагнитченности; а — парамагнитное; б — равновесие подзон, возникшее из-за обменного взаимодействия (случай слабого зонного магнетизма). В результате верхний уровень подзоны (-) оказался выше первоначального значения μ на величину Δ , а верхний уровень подзоны (+) — ниже на Δ . При установлении равновесного состояния из подзоны (-) электроны (+) переходят около $\mu = \mu_+$ — в электроны на атом; в — равновесное состояние в случае слабого зонного магнетизма; г — равновесное состояние в случае сильного зонного магнетизма.

на каждый атом, μ_B — магнетон Бора, $k_B = \pi U/2$ — энергияч. параметр взаимодействия, U — параметр обменного взаимодействия между электронами с противоположно направленными спинами.

В рамках С. м. феноменологич. описание обменного взаимодействия электронов с противоположно направленными спинами может быть учтено с помощью введения аналога *молекулярного поля* Вейса, определяемого величиной Δ , не зависящей от импульса электрона k . Вклад от взаимодействия электронов с параллельными спинами не зависит от k и σ и может быть учтён сдвигом начала отсчёта энергии на пост. величину. В С. м. энергия межэлектронного взаимодействия зависит только от α -компоненты полного спина, что делает модель неизвариантной относительно вращений. В рамках микроскопич. описания С. м. можно рассматривать как *среднее поля приближение* для Хаббарда модели.

Полное число коллективизированных электронов n и намагнитченность $M = m n \mu_B$ в С. м. определяются самосогласованно:

$$Nn = \int d\mathcal{E} \rho(\mathcal{E}) [f(\mathcal{E} + \Delta) + f(\mathcal{E} - \Delta)],$$

$$M/n\mu_B = \int d\mathcal{E} \rho(\mathcal{E}) [f(\mathcal{E} + \Delta) - f(\mathcal{E} - \Delta)], \quad (3)$$

где f — функция Ферми — Дирака

$$f(x) = \frac{1}{\exp(x - \mu)/kT + 1}.$$

Здесь $\rho(\mathcal{E})$ — плотность электронных состояний, \mathcal{E} — энергия, μ — хим. потенциал. Для упрощения расчётов $\rho(\mathcal{E})$ обычно аппроксимируется прототип f -цвей, не зависящей от темп-ры и концентрации электронов [2-4].

В зависимости от заполнения подзон с противоположными направлениями магн. моментов электронов различают сильный и слабый зонный магнетизм (рис.). В случае слабого зонного ферромагнетизма спонтанная намагнитченность мала и, воспользовавшись разложением входящих в выражения (3) и (4) f -цвей в ряд по степеням малых параметров $\mu_B H/\mathcal{E}_F$, kT/\mathcal{E}_F , $m\theta/\mathcal{E}_F$ (здесь \mathcal{E}_F — ферми-энергия, при $T = 0$ хим. потенциал $\mu = \mathcal{E}_F$), легко можно получить значение темп-ры Кюри T_C (см. Кюри точка), определяемой в С. м. как

теми-ра, при k -рой дифференц. магн. восприимчивость в нулевом анем. поле испытывает расхождение. При $T = 0$ ферромагн. состояние будет существовать только тогда, когда выполняется *Стокера критерий ферромагнетизма*: $\rho(\delta_F)U > 1$. В этом случае легко рассчитывается температурная зависимость магн. восприимчивости и спонтанной намагниченности $M(T)$, k -рая вблизи T_C даёт критич. показателю $\beta = 1/2$, совпадающий с результатами *Ландау теории фазовых переходов 2-го рода*. Полученные в рамках этого разложения графики зависимости M^2 от M/H (график и Аппро-та — Белова — Нокса) представляют собой прямые линии, причём при $T = T_C$ прямая проходит через начало координат. Предсказанная моделью зависимость $M(T)$ была впервые получена экспериментально для ферромагнетика $ZrZn_2$, что послужило аргументом в пользу существования ферромагнетиков с коллективизиров. носителями магн. момента.

С. м. достаточно хорошо аппроксимирует свойства зонн. состояний зонных магнетиков. В отличие от *Гейзенберга модели*, С. м. позволяет получить дробные значения магн. моментов (в единицах μ_B на атом), наблюдаемые в Fe, Ni, Co. Однако при конечных темп-рах С. м. обнаруживается много несоответствий с результатами эксперим. исследований зонных магнетиков. Значения T_C , рассчитанные для металлов группы Fe, оказываются сильно завышенными. Экспериментально не подтверждается тот факт, что обменное расщепление зон пропорционально намагниченности (2). Существ. недостатком модели является то, что при $T > T_C$ магн. восприимчивость не подчиняется *Кюри — Вейса закону*. С. м. также не может объяснить *антиферромагнетизм* металлов группы Fe, таких, как Mn, Cr. Наблюдаемое при $T > T_C$ спин-флуктуат. возбуждения также, естественно, не воспроизводятся в этой простой модели, но могут быть объяснены в спин-флуктуат. теории магнетизма [6] (см. *Спиновые флуктуации*).

Лит.: 1) Stoner E. G., Collective electron ferromagnetism, Proc. Roy. Soc., 1938, v. A165, p. 372; 2) Wolf J. H. E., The theoretical and experimental status of the collective electron theory of ferromagnetism, Rev. Mod. Phys., 1953, v. 25, p. 211; 3) Magnetism, v. 4, ed. by G. T. Rado, H. Suhl, N. Y. L., 1966, 4) Воеводин Я. С. В., Магнетизм, М., 1971; 5) Физ. теория магнетизма, пер. с англ., 2 изд., М., 1985; 6) Мория Т. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами, пер. с англ., М., 1988.

А. В. Вейсес, А. В. Грановский, О. А. Котельникова.

СТОМЛИ ВОЛНЫ — упругие волны, распространяющиеся вдоль плоской границы двух твёрдых полупространств, мало различающихся по плотности и модулю упругости; являются разновидностью *поверхностных акустических волн*. Описаны Р. Стокли (R. Stoneley) в 1924 г. в. состоит как бы из двух *Рэлея волн* (по одной в каждой среде). Параллельная и перпендикулярная граничной поверхности компоненты колебат. смещений этих волн убывают в глубь каждой из сред, так что энергия С. в. сосредоточена в двух граничных слоях толщиной $\sim \lambda$ каждой. Фазовая скорость С. в. меньше фазовых скоростей продольной c_L и поперечной c_T упругих волн в обеих граничных средах. При равенстве фазовых скоростей упругих волн в этих средах ($c_L = c_{L_1} = c_{L_2}$, $c_T = c_{T_1} = c_{T_2}$) по при равенции плотностей ($\rho_1 \neq \rho_2$) С. в. всегда существует. При этом, если $\rho_1/\rho_2 \rightarrow \infty$, С. в. переходит в волны Рэлея.

СТОМА — один из простых *поляризационных приборов*, представляющий собой набор прозрачных плоских пластин, устанавливаемых под нек-рым углом к падающему свету. Коэф. пропускания и отражения для компонент световых лучей, поляризованных параллельно и перпендикулярно плоскости падения на С., различны (см. *Френеля формулы*). Поэтому естественный свет, прошедший через С., поляризуется: в нём преобладает компонента, алгебр. вектор k -рой лежит в плоскости падения. Степень поляризации p тем выше, чем больше наклон лучей к С., однако оптим. углом установки С. является угол Брюстера (см. *Брю-*

стера закон), при k -ром прозрачность С. максимальна (ок. 50%).

Для видимой области спектра пластины С. выполняются из *оптического стекла* очень малой толщины, чтобы уменьшить потери на поглощение. При показателе поглощения стекла $n = 1,5$ практически полную поляризацию ($p = 0,99$) даёт С. из 16 пластин. Для ИК-области применяют С. из пластин фтористого лития, флюорита и др. с тонкими селеновыми, германиевыми или кремниевыми покрытиями. Большие n ($\sim 2-4$) таких покрытий позволяют получить требуемую степень поляризации p при небольшом числе пластин.

СТОХАСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (от греч. *stochastikos* — умеющий угадывать) — нерегулярные, внешне неотличимые от реализации *случайного процесса* колебания в полностью детерминированной (без шумов и флуктуаций) нелинейной системе.

Сложное поведение нелинейных колебат. систем наблюдалось (1920-е — 50-е гг.) задолго до осознания факта возможности существования стохастичности в таких системах (эксперименты Ван дер Поля и Ван дер Марка [1], лагуновское динамо [2], распределенная система авторегулирования темп-ры [3]). Кроме того, хотя в то время существовали искр-ые элементы матем. аппарата для описания неинвариального поведения траекторий *динамических систем* в фазовом пространстве (гомоклинич. структуры Пуанкаре [4]), однако представления о том, что детерминиров. системы могут вести себя хаотичски, ещё не проникли ни в физику, ни в математику. Качественное изменение ситуации произошло в 1960-е гг. в связи с открытиями в математике [5—6] и компьютерными исследованиями моделей физ. систем.

С. к., как и истинно шумовые колебания, характеризуются сплошным *Фурье спектром* и спадающей автокорреляц. ф-цией (см. *Хаос*). Отличает их от случайных флуктуаций то обстоятельство, что они могут генерироваться динамик. системой с конечным числом степеней свободы (в то время как генерация шума требует от системы возбуждения бесконечного числа независимых степеней свободы). Физ. природа возникновения сложного запутанного поведения конечномерной системы связана с неустойчивостью всех (или большинства) индивидуальных движений. Неустойчивость траекторий, располагающихся в органич. области фазового пространства, и приводит к перемешиванию, следствием k -рой является запутанность, сложность, стохастичность движения. Важными характеристиками этой сложности и запутанности являются фрактальная размерность предельного множества (*странного аттрактора*) A и топологич. энтропия системы на нём (см. *Фракталы*).

Выберем на странном аттракторе ансамбль из отрезков траекторий длительности T , отстоящих друг от друга на расстояние ε . Предположим, что любой отрезок длительности T произвольной траектории в аттракторе лежит в ε -окрестности хотя бы одного из отрезков. Обозначим через $C(T, \varepsilon)$ число отрезков (элементов) в ансамбле. При уменьшении ε или увеличении T число $C(T, \varepsilon)$ увеличивается. Рост $C(T, \varepsilon)$ при убывании ε естественно связан с геом. сложностью аттрактора. Увеличение же $C(T, \varepsilon)$ при возрастании T есть следствие неустойчивости траекторий в аттракторе. Рассмотрим следующие характеристики движения на аттракторе:

$$h = \lim_{T \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln C(T, \varepsilon)}{T}; \quad c = \lim_{T \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln C(T, \varepsilon)}{-\ln \varepsilon}.$$

Величину h наз. топологич. энтропией, c — фрактальной размерностью аттрактора. Сигналу (реализации, наблюдаемой), с k -рым имеет дело исследователь, в эффективном фазовом пространстве (возможно, бесконечномерном) исследуемой системы отвечает предельное множество соответствующих траекторий. Его размерность естественно называть размерностью реализ-

зации, а топологич. зитронью системы, рассматриваемой лишь на этом предельном множестве, можно назвать топологич. зитронью реализацией. Существуют алгоритмы определения этих величин, к-рые позволяют вычислить их для сигналов, генерируемых реальными процессами [7] (течение жидкости, зитрафалограмы и пр.). Количеств этих величин свидетельствует о динамич. характере исследуемого процесса, в сами они характеризуют «стенень стохастичности» системы.

Стохастичность гамилтоновых систем. Стохастич. свойства демонстрируют даже очень простые гамилтоновы системы, напр. маятник под действием внеш. периодич. силы:

$$\ddot{x} + \sin x = b \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega.$$

Фазовое пространство этой системы трёхмерно и очевидно, что нач. фазовый объём сохраняется. Если в такой системе (в определ. области параметров) рассмотреть каплю «фазовой жидкости» в пространстве (x, z, θ) , то можно обнаружить, что через нек-рое время она, сложным образом деформируется, заполнит определ. область в фазовом пространстве, к-рая и будет соответствовать стохастич. движениям (рис. 1).



Рис. 1.

Однако наряду с этой областью перемешивания (или областью стохастичности) в фазовом пространстве (1) всегда будут существовать нач. условия, к-рым отвечает регулярное периодическое или квазипериодическое поведение. Особенно наглядно это видно на секущей плоскости $\theta = \theta_0 \equiv \theta_0 + 2\pi n$ (на рис. 2 показаны следы фазовых траекторий — траектории отображения Пуанкаре). Регулярным движениям отвечают двумерные торы, на к-рых лежат траектории, соответствующие условно периодич. движениям (на рис. 2 — это замкнутые кривые). В области хаоса эти торы разрушены. Очевидно, в трёхмерном фазовом пространстве (и в четырёхмерном на трёхмерной поверхности вост. внешней) области хаотического и регулярного поведения разделены. Такие системы наз. системами с разделённым фазовым пространством [8].

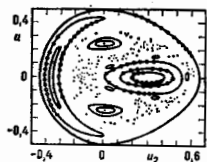


Рис. 2.

Если фазовое пространство имеет размерности больше четырёх, то геом. запреты, гарантирующие разделение хаотических и регулярных движений, уже не существует и области стохастич. поведения в разных частях фазового пространства могут соединяться друг с другом отрезками одной и той же траектории. Обычно это происходит вдоль *separatrix* (стохастич. диффузия, или диффузия Арнольда [8]).

Возникновение стохастичности в гамилтоновых системах типа (1) определяется значением амплитуды внеш. силы, что имеет простой физ. смысл. При достаточно больших амплитудах появляется большое число гармоник осн. частоты колебаний, на каждой из к-рых возможен нелинейный резонанс; при дальнейшем увеличении амплитуды области резонанса в фазовом пространстве, соответствующие этим движениям, перекрываются (т. е. перекрывают резонансы Ньюкова). Обнаружение стохастич. поведения гамилтоновых

систем, обладающего не только *эродичностью*, но и более сильными статистич. свойствами (перемешиванием, спадением автокорреляц. ф-ции и т. п.), позволяют построить динамич. модели, на основе к-рых могут быть получены осн. законы статистич. механики без предварит. гипотез. Это — модели типа бильярда Синая [9], газа Лоренца [10] и пр.

Стохастичность автоколебания. В системах с диссипацией, напр. в системе

$$\ddot{x} + k\dot{x} + \sin x = b \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega, \quad (2)$$

фазовый объём не сохраняется — он сжимается, поэтому можно было бы ожидать, что движение системы может лишь угнестись. Однако стохастич. поведение в таких системах сохраняется; лишь незначительно (в зависимости от величины k) уменьшается размерность стохастич. множества, к-рое в данном случае является странным аттрактором. Стохастич. *автоколебания* реализуются не только в простой модели (2) неавтономного осциллятора, но и практически в любой нелинейной колебательной диссипативной системе с периодич. силой, если её амплитуда не слишком мала, даже если потенциал осциллятора имеет лишь один минимум (в фазовом пространстве неавтономной системы одно положение равновесия), как в системе, описываемой ур-нием

$$\ddot{x} + k\dot{x} + x + x^3 = b \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega \quad (3)$$

(нелинейный резонанс с учётом затухания). Существование стохастич. автоколебаний в системе

$$\ddot{x} - k\dot{x}(1-x^2) + x^3 = b \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega, \quad (4)$$

описываемой (с учётом нелинейной реактивности), в частности, синхронизацию колебаний, означает, кроме прочего, и то, что при переходе в области параметров через границу режима захватывания могут возникнуть не только бенины, но и сложные колебания, ничем не отличимые от случайных. На рис. 3 приведены аттракторы систем, описываемых ур-ниями (3) и (4) при соответствующих значениях параметров.

Движения на странном аттракторе — установившиеся стохастич. автоколебания. Подобно движению автоколебаний, матем. образом к-рых является предельный цикл, осн. характеристики установившихся движений (спектр колебаний, размерность, зитронья и др.) на странном аттракторе не зависят от нач. условий. Нач. условия сказываются лишь на характере переходного процесса. Несмотря на то, что странный аттрактор состоит из неустойчивых траекторий, т. е. движение рядом с каждой из них происходит лишь конечное время, однако переходы с одной неустойчивой траектории на другую происходят таким образом, что движение систем осуществляется вдоль траекторий, тоже принадлежащей странному аттрактору [11].

В многомерных системах размерность странных аттракторов может быть много меньше размерности фазового пространства, что соответствует частичной синхронизации степеней свободы системы.

Пути возникновения стохастических колебаний [12-13]. Последовательности *бифуркаций* (сепаратив, путь), приводящие к возникновению С. к. при изменении параметров системы, могут быть бесконечно разнообразны, однако элементарных бифуркаций или их последовательностей, содержащихся в этих сепаративах, не так много.

Рассмотрим вначале режимы мягкого возникновения стохастич. автоколебаний. Осн. бифуркации в этом случае представлены на рис. 4. Это — рождение тора из предельного цикла при потере им устойчивости, бифуркация удвоения периода, слияние устойчивого и седлового циклов и их исчезновение, сопровождающиеся возникновением странного аттрактора, сложные деформации (гофрирование) тора и его разру-

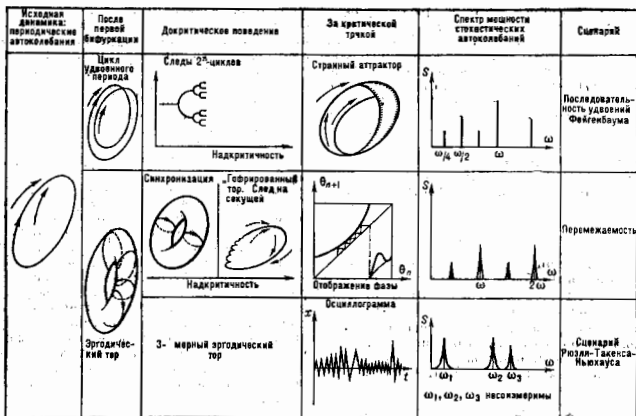


Рис. 3.

шесте, сопровождающиеся возникновением большого числа гармоник и субгармоник в спектре колебаний.

Для «экзотического» режима возникновения С. к. характерно превращение неупорядоченных гомоклиник, структур в фазовом пространстве, образовавшихся в результате потери устойчивости простыми аттракторами, в странный аттрактор.

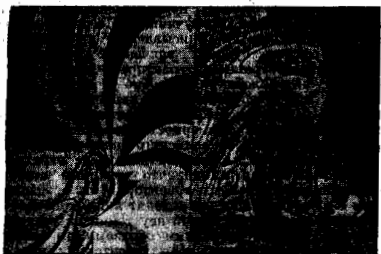


Рис. 4.

Стохастические колебания в распределённых системах [14] — неупорядоченное поведение не только во времени, но и в пространстве. Стену неупорядоченности этих движений связана с числом независимых степеней свободы, формирующих это движение.

Пример подобного неупорядоченного движения распределённой гамильтоновой системы — стохастическое движение солитона, описываемое нелинейным Шрёдингера уравнением с гармонич. потенциалом:

$$\Psi_t = i(\Psi_{xx} + n(x, t)\Psi + |\Psi|^2\Psi). \quad (5)$$

Для «медленных» переменных, определяющих координаты центра солитона, в одномерной ситуации получается уравнение движения, совпадающее с (1). Т. о., один из механизмов стохастизации волнового поля связан с формированием локализов. образования (солитона) и его хаотич. блуждания в фаз. пространстве, подоб-

ного нерегулярному движению изображающей точки в фазовом пространстве нелинейного осциллятора (1).

В диссипативных распределённых системах незатухающие С. к. возможны лишь при наличии источника энергии (потоки массы или тепла в гидродинамич. течениях, накачка в лазерах, пост. или периодич. магн. поле при возбуждении спинового волн и т. д.). Установившиеся стохастич. пульсации в распределённой диссипативной системе, к-рым соответствуют конечномерные аттракторы, есть стохастич. автоколебания. При не слишком больших числах Рейнольдса черты гидродинамич. турбулентности описываются движениями на конечномерном странном аттракторе, размерность к-рого обычно растёт с ростом числа Рейнольдса.

Лит.: 1) Van der Pol B., Van der Mark J., Frequency demultiplication, «Nature», 1927, т. 120, p. 363; 2) Rikitake T., Oscillations of a system of disc dynamics, «Proc. Camb. Philos. Soc.», 1958, v. 54, № 1, p. 89; 3) Алексеев А. С., Двухпозиционный регулятор температуры с зоной опережения, в сб.: Памяти А. А. Андропова, М., 1985; 4) Пузыкин В. А., Набр. труды, т. 2, М., 1972; 5) Аносов Д. В., Геодезические потоки на замкнутых римановых многообразиях отрицательной кривизны, «Тр. Мат. ин-та АН СССР», 1967, т. 90; 6) Сивяк В. И. Г., Марковские разбиения и У-лиффеоформизмы, «Фундаментальный анализ и его приложения», 1968, т. 2, в. 1, с. 64; 7) Рабинович М. И., Суцук М. М., Регулярная и хаотическая динамика структур в течениях жидкости, «УФН», 1980, т. 160, с. 3; 8) Лихтенберг А., Либман М., Регулярная и стохастическая динамика, пер. с англ., М., 1984; 9) Бунимович Л. А. и др., Эргодическая теория гладких динамических систем, в кн.: Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, т. 2, М., 1985; 10) Сивяк В. И., Чернов Н. И., Ситрогид газы твердых сфер по отношению к группе пространственно-временных сдвигов, в сб.: Труды семинара им. И. Г. Петровского, в. 8, М., 1982, с. 218; 11) Аносов Д. В., М., Яносов В. А., Дополнение. Символическая динамика и гиперболические динамические системы, в кн.: Боуэн Р., Методы символической динамики, пер. с англ., М., 1978; 12) Рабинович М. И., Трубецков Д. И., Введение в теорию колебаний и волн, М., 1984; 13) Шустер Г., Деструктивный хаос, пер. с англ., М., 1988; 14) Рабинович М. И., Стохастическое автоколебание и турбулентность, «УФН», 1978, т. 125, с. 123.

В. С. Абрамочкин, М. И. Рабинович, **СТОХАСТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ — уравнения**, описывающие поведение реализаций случайных процессов, волн и полей под действием случайных сил и флуктуирующих параметров, при случайных начальных или граничных условиях. Анализ С. у. состоит в определении статистич. характеристик их решений, напр. матем. ожидания, корреляц. ф-ции, плотности вероятности.

Первоначально С. у. были предложены П. Ланжевеном (P. Langevin) для описания броуновского движения (см. *Ланжевено уравнение*). С. у. используют при изучении флуктуаций в радиотехн. устройствах и квантовых генераторах, при анализе вибраций, в теории связи и адаптивного управления, при исследовании распространения волн в случайно-неоднородных средах и т. д. Случайные процессы обычно описывают системой обыкновенных дифференц. С. у.

$$dx/dt = a(x, t) + b_{\alpha}(x, t)\xi_{\alpha}(t),$$

где a_{α} , b_{α} — детерминиров. ф-ции, ξ_{α} — матрица случайных сил с известными статистич. характеристиками.

Методы анализа С. у. разбивают на 2 группы. Методы 1-й группы состоят в точном или приближенном решении дифференц. ур-ний и последующем вычислении статистич. характеристик найденных решений. В методах 2-й группы от С. у. переходят к ур-ниям для статистич. характеристик решений, а затем решают полученные детерминиров. ур-ния.

В методах 2-й группы возникает проблема замыкания ур-ний и расщепления корреляций. Напр., переходом от С. у.

$$dx/dt = a(x) + b(x)\xi(t), \quad (1)$$

$$t > s, \quad x(t) = y,$$

к ур-нию для среднего $\langle x(t) \rangle$ (угл. скобки означают статистич. усреднение):

$$d\langle x(t) \rangle/dt = \langle a(x) \rangle + \langle b(x)\xi(t) \rangle. \quad (2)$$

Это ур-ние может оказаться не замкнутым относительно $\langle x \rangle$ по двум причинам: 1) если $a(x)$ — нелинейная ф-ция, среднее $\langle a \rangle$ не выражается через $\langle x \rangle$; 2) среднее $\langle b\xi \rangle$ определяется совм. статистич. свойствами $x(t)$ и $\xi(t)$. При расщеплении средних типа $\langle \varphi(x)\xi \rangle$ применяют теорию возмущений по малому параметру $\alpha = \tau_1/\tau_2$, где τ_1 — время корреляции $\xi(t)$, τ_2 — характерный масштаб $x(t)$. Если α — решение С. у. (1), а $\xi(t)$ — гауссов белый шум с коррелл. ф-цией, пропорциональной δ -функции,

$$\langle \xi(t)\xi(t+\tau) \rangle = D\delta(\tau),$$

т. е. $\alpha = 0$, то справедлива точная ф-ла расщепления

$$\langle \varphi(x(t))\xi(t) \rangle = D\langle b(\varphi(x))' \rangle / 2.$$

В этом случае ур-ние (2) принимает вид:

$$d\langle x \rangle/dt = \langle a \rangle + D\langle b b' \rangle / 2, \quad (3)$$

$$t > s, \quad \langle x(t) \rangle = y.$$

В случае линейных С. у. подобное расщепление приводит к замкнутым ур-ниям для моментов. Напр., если в С. у. (1) $a = ax$, $b = bx$, то ур-ние (3) замыкается:

$$d\langle x \rangle/dt = [a + Db^2/2] \langle x \rangle.$$

Если С. у. нелинейно, то моменты его решения удовлетворяют бесконечной цепочке зацепляющихся ур-ний, при обрывании к-рой используют доп. приближения.

Для исследования статистич. свойств нелинейных С. у. тип (1) удобен аппарат марковских случайных процессов. Так, если $\xi(t)$ — гауссов белый шум, то решение С. у. представляет собой непрерывный марковский (диффузионный) процесс, плотность вероятности переходов к-рого удовлетворяет Фоккера — Планка уравнению. Плотность вероятности переходов для скачкообразных марковских процессов удовлетворяет интегродифференциальному Колмогорова — Феллера уравнению. Можно антропизировать случайные воздействия марковскими процессами, напр. считать, что

в С. у. (1) $\xi(t)$ — случайный процесс, удовлетворяющий С. у.:

$$d\xi/dt + k\xi = \eta(t), \quad \xi(0) = \xi,$$

где $\eta(t)$ — гауссов белый шум. При этом совокупность $\langle x(t) \rangle$, $\xi(t)$ образует двумерный марковский процесс, совместная плотность вероятности переходов к-рого удовлетворяет двумерному ур-нию Фоккера — Планка.

Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, напр. в турбулентной атмосфере, ионосфере, межзвездной плазме и т. д., описывается С. у. с частными производными. Примером служит Гельмгольца уравнение для стохастич. Грина функции:

$$\Delta G + k^2(1 + \epsilon(r))G = \delta(r - r_0), \quad (4)$$

где $\epsilon(r)$ — случайное поле неоднородностей среды, k — волновое число. Мн. методы исследования с помощью (4) статистики случайных волн опираются на анализ рядов теории возмущений по ϵ :

$$G(r, r_0) = G_0(r, r_0) - k^2 \int G_0(r, r_1)\epsilon(r_1)G_0(r_1, r_0)dr_1 + \dots, \quad (5)$$

где G_0 — невозмущенная ф-ция Грина. Если рассеяние волны на случайных неоднородностях среды невелико, то пользуются броуновским приближением (приближением однократного рассеяния), удерживая в правой части (5) лишь два первых слагаемых. Если рассеяние существенно многократное, то при расчёте статистич. характеристик волны и выводе приближенных замкнутых ур-ний для ср. поля $\langle G \rangle$, ф-ция когерентности и т. д. производят селективное суммирование ряда теории возмущений, используя Фейнмана диаграммы.

При анализе распространения и рассеяния волн в случайно-неоднородных средах применяют и методы, основанные на переходе от исходных С. у. к более простым. Сюда относятся, в частности, геометрической оптики метод, неравновесного уравнения приближение, планки возмущений метод, приближение случайного фазового экрана, переход к ур-нию переноса излучения.

Лит.: Введение в статистическую радиофизику, ч. 1 — Ритов С. М., Случайные процессы, М., 1976; ч. 2 — Ритов С. М., Кравцов Ю. А., Татарский В. И., Случайные поля, М., 1978; Справочник по теории вероятностей и математической статистике, 2 изд., М., 1988; Клиффорд В. И., Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах, М., 1980. А. Н. Малахов, А. И. Сивчев.

СТОЯЧАЯ ВОЛНА — периодическое или квазипериодическое во времени синфазное колебание с характерным пространственным распределением амплитуды — чередованием узлов (нулей) и пучностей (максимумов). В линейных системах С. в. может быть представлена как сумма двух бегущих волн равной амплитуды, распространяющихся навстречу друг другу, и наоборот — любая бегущая волна составляет суперпозицию двух С. в. равной амплитуды, сдвинутых по фазе на четверть периода. Простейший пример С. в. — плоская звуковая С. в. внутри заполненной воздухом трубы (напр., органа) при закрытом (с идеально твёрдой стенкой) и открытом (но нелучающим) концах (рис.). На твёрдой стенке образуются узлы скорости и пучность перепада давления, на открытом конце скорость максимальна, а перепад давления отсутствует.



Распределение давлений и скоростей в стоячей волне при открытом и закрытом концах не лучающей звуковой трубе.

зует; поэтому обе картины сдвинуты относительно друг друга на четверть длины волны. Аналогичное распределение имеет место для электрич. и магн. полей в линии передачи или *волноводе* с идеально «закороченным» или открытым концом, а также при нормальном падении плоской эл.-магн. волны на идеально отражающую стенку.

В отличие от бегущей волны, в С. в. не происходит переноса энергии, а осуществляется лишь пространственная передача энергии одного вида в энергию др. вида с удвоенной частотой (электрической в магнитную, кинетической в потенциальную и т. п.). В известном смысле области между любыми चुम्бачными и узлами можно рассматривать как автономные системы, а саму С. в. как распределённое в пространстве колебание (см. *Волны*).

Чисто С. в. могут устанавливаться только при отсутствии затухания в среде и при полном отражении от границ. В противном случае кроме С. в. появляются бегущие волны, доставляющие энергию к местам поглощения или излучения. Распределение волнового поля при этом характеризуется коэф. стоячести волны — КСВ (см. *Бегущая волна*), а соотношение между средней за период колебаний $T = 2\pi/\omega$ запасённой в С. в. энергией W и мощностью P , уносимой бегущей волной, характеризуется добротностью колебания $Q = \omega W/P$. Невырожденные *нормальные колебания* обьёмных резонаторов без потерь суть С. в., а *нормальные волны* в волноводах представляют собой волны, бегущие в одном направлении и стоячие в направлениях, перпендикулярных осн. волновода.

Лит.: Горелин Г. С., *Колебания и волны*, 2 изд., М., 1956; Крауфорд Ф., *Волны*, пер. с англ., 3 изд., М., 1984. М. А. Миллер, Е. В. Суворова.

СТРАННОСТЬ (S) — аддитивное квантовое число, являющееся наряду с *очарованием* (C) и *красотой* (b) специфич. характеристикой адронов. Все адроны обладают определёнными целочисленными (нулевыми, положительными или отрицательными) значениями S , причём $|S| \leq 3$. Античастицы имеют С. противоположного знака по сравнению со С. частиц. Адроны с $S \neq 0$ (шо с $C = 0$ и $b = 0$) называются *странными* и *частицами*. (Частицы, не участвующие в сильном взаимодействии, — фотону, *лептонам* приписывается значение $S = 0$.) В процессах, обусловленных сильными и эл.-магн. взаимодействиями, С. сохраняется, т. е. суммарная С. исходных и конечных частиц одинакова. В процессах слабого взаимодействия (протекающих за счёт *заряженных токов*) С. может нарушаться, при этом различие в суммарной С. начальных и конечных частиц $|\Delta S| = 1$. По совр. представлениям, наличие у нек-рых адронов $S \neq 0$ связано с тем, что а их состав входит один или неск. странных *кварков*, для каждого из к-рых $S = -1$.

Исторически квантовое число С. было введено для истолкования факта отсутствия (запрета) случаев одиночного рождения *K-мезонов* и *гиперонов* при столкновениях л-мезонов и нуклонов с нуклонами; наблюдение только совместного рождения *K-мезона* и *гиперона* в этих процессах удалось объяснить, приписав компонентам пары равные по величине, но противоположные по знаку значения особого квантового числа, названного С., и предположив сохранение С. в сильном взаимодействии. Связь С. с др. квантовыми числами адронов даётся обобщённой *Гелл-Манна — Нисиджимы формулой*.

А. А. Комар.
СТРАННЫЕ ЧАСТИЦЫ — адроны, обладающие ненулевым значением квантового числа *странности* S (в отличие от «обычных», «нестранных» адронов, напр. л-мезонов, нуклонов, для к-рых $S = 0$) и нулевыми значениями др. специфич. характеристик адронов — *очарования*, *красоты*. К С. ч. относятся *K-мезоны*, *гипероны*, нек-рые *резонансы*. Все С. ч. нестабильны. Странные резонансы распадаются очень быстро (за время $\sim 10^{-12}$ с) за счёт *сильного взаимодействия*; суммарная

странность продуктов их распада равна странности исходной частицы. Остальные С. ч. квазистабильны и распадаются за счёт *слабого взаимодействия* относительно медленно (за время $\sim 10^{-8} - 10^{-10}$ с) на частицы с меньшей странностью, нестранные частицы и (или) *лептоны*; в этом случае суммарная странность продуктов распада по модулю меньше странности исходной частицы на единицу. С. ч. с большей вероятностью рождаются при столкновениях «обычных» адронов за счёт сильного взаимодействия, но при этом они обязательно возникают парами (или в большем кол-ве), так, чтобы их суммарная странность оказалась равной нулю. Распадаются же С. ч. на «обычные» за счёт слабого взаимодействия с очень малой вероятностью. Эта «странность» в поведении частиц и явилась причиной их названия.

Лит. см. при ст. К-мезоны, Гипероны. А. А. Комар.

СТРАННЫЙ АТТРАКТОР — притягивающее множество неустойчивых траекторий в фазовом пространстве диссипативной *динамической системы*. С. а., в отличие от аттрактора, не является многообразием (т. е. не является кривой или поверхностью); его геом. устройство очень сложно, а его структура фрактальна (см. *Фракталы*). Поэтому он получил назв. «странный» [Д. Рюэли (D. Ruelle), Ф. Такенс (F. Takens)]. Тот факт, что все траектории, расположенные в окрестности С. а., притягиваются к нему при $t \rightarrow \infty$, принципиально связан с характером неустойчивостей составляющих его траекторий, к-рые неустойчивы по одним и устойчивы (притягивающие) по др. направлениям (т. е. являются седловыми; см. также *Бифуркации. Пределный цикл*). Траектории С. а. описывают стационарные стохастич. автоколебания, поддерживаемые в диссипативной системе за счёт энергии внеш. источника. С. а. характерны лишь для автоколеб. систем, размерность фазового пространства к-рых больше двух (рис. 1). Первая исследованная система со С. а. — *Лоренца система* — трёхмерна.

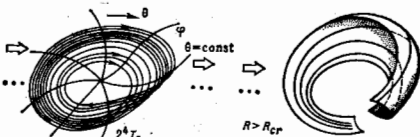


Рис. 1. Странный аттрактор в системе, описываемой уравнениями типа (1).

Системы с периодич. автоколебаниями, матем. образом к-рых является предельный цикл, удаётся исследовать достаточно полно с помощью методов качественной теории дифференц. ур-ий. Построение же теории *стохастических колебаний*, заключающееся, в частности, в определении (предсказании) характеристик и свойств С. а. по заданным параметрам системы, чрезвычайно затруднительно даже для трёхмерных систем. Подобное построение удаётся провести, однако, в тех случаях, когда в системе существует малый параметр, носящий название *параметра отображения* Пуанкаре. Перейти от анализа траекторий в трёхмерном пространстве к исследованию траекторий отображения.

П р и м е р [1]. Подобно тому, как генератор Вандер-Поля является простейшим и канонич. примером системы, демонстрирующей периодич. автоколебания, схема, представленная на рис. 2а и определяющая неслемо усложнённый генератор Вандер-Поля, может служить одним из простейших примеров генераторов стохастич. автоколебаний. От генератора Вандер-Поля с контуром в цепи сетки эта схема отличается лишь включённым в контур последовательно с индуктивностью туннельным диодом или др. нелинейным элементом.

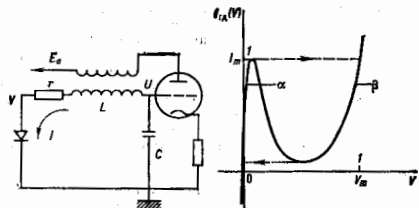


Рис. 2. Принципиальная схема (а) простого генератора шума — генератора Валлер-Поля в сеточный контур которого добавлен туннельный диод. Вольт-амперная характеристика (б) нелинейного элемента — туннельного диода.

том с вольт-амперной характеристикой, представленной на рис. 2 б. Пока ток I в контуре и напряжение на сетке U малы, туннельный диод не оказывает существенного влияния на колебания в контуре, и они, как и в обычном ламповом генераторе, нарастают. При этом через туннельный диод течёт ток I , а напряжение на нём определяется ветвью α характеристики $I(V)$. Когда же ток I достигает значения I_m , происходит почти мгновенное переключение туннельного диода (быстрота переключения связана с малостью ёмкости C_1) — скачком устанавливается напряжение V_m . Затем ток через туннельный диод уменьшается и происходит его обратное переключение с участка β на α . В результате двух переключений туннельный диод почти полностью отдаёт поступившую в контур энергию и колебания начинают снова нарастать. (При рассмотрении работы схемы характеристику лампы можно считать линейной; это оправдано тем, что в интересующем нас режиме колебания ограничиваются нелинейной характеристикой туннельного диода.) Т. о., генерируемый сигнал $U(t)$ представляет собой последовательность скачков нарастающих колебаний; окончание каждого скачка характеризуется скачком напряжения $V(t)$.

Для количественного описания работы схемы исходные уравнения

$$LC \frac{dI}{dt} = (MS - rC)I + C(U - V),$$

$$C \frac{dU}{dt} = -I, \quad \frac{dV}{dt} = I - I_{mD}(V)$$

преобразуют к безразмерному виду:

$$\dot{x} = 2\lambda x \times y - g_2 z, \quad \dot{y} = -x, \quad \dot{z} = x - f(z), \quad (1)$$

где $x = I/I_m$, $z = V/V_m$, $y = U/V_m R/I_m \sqrt{LC}$, $f(z) = I_{mD}(V_m z)/I_m$ — нормированная характеристика диода. Здесь $\mu = 9C_1/C$ — малый параметр ($\mu \ll 1$). Поэтому все движения в фазовом пространстве (рис. 3)

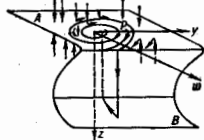


Рис. 3. Поведение траекторий в фазовом пространстве системы (1) при $\mu = 0$.

можно разбить на быстрые переключения диода (прямые $x = \text{const}$, $y = \text{const}$) и медленные, при которых напряжение на диоде «следит» за током; соответствующие траектории лежат на поверхностях A и B [$x = f(z)$, $f'(z) > 0$], отвечающих участкам α и β характеристики диода.

Система имеет одно неустойчивое [при $\mu > g_1 f'(0)$] состояние равновесия $x = y = z = 0$ типа седло. Траектории, лежащие на поверхности A , раскручиваются вокруг неустойчивого фокуса и в конце концов достигают края поверхности A . Здесь происходит срыв точки, отображающей на фазовой траектории состояние системы (т. е. изображающей точки) по линии быстрых движений на поверхность B . Пройдя по B , изображающая точка срывается обратно на поверхность A и попадает в окрестности состояния равновесия — начинается новый дуг нарастающих колебаний. Построенная картина движения соответствует реализации, представленной на рис. 4, и её спектру мощности.

Отображение Пуанкаре, соответствующее уравнениям (1), при $\mu = 0$ усучно можно описать непрерывной функцией, график которой приведён на рис. 5. Линейный участок I с коэф. угла наклона, большим единицы,

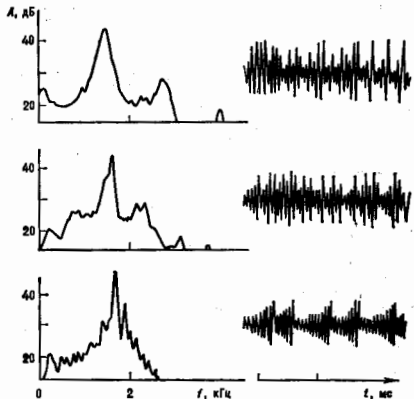


Рис. 4. Спектр мощности сигнала, генерируемого схемой, представленной на рис. 2а, и осциллограмма этого сигнала.

описывает раскручивание траектории на поверхности медленных движений A , соответствующей нарастающим колебаниям в контуре. Участок II описывает этап возвращения траекторий, сорвавшихся с поверхности A на поверхность B , обратно на A (см. рис. 3). Все траектории, лежащие вне основания обозначенного пунктиром квадрата, входят в него при асимптотически

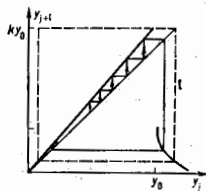


Рис. 5. График функции $f(z)$, описывающей динамику схемы рис. 2 при $\mu = 0$.

большим значениям времени, т. е. область D — поглощающая и содержит аттрактор. Все траектории внутри этой области неустойчивы, т. е. аттрактор является странным. При малых значениях $\mu > 0$ свойства стохастичности движений (как показывают численные исследования) сохраняются.

Фрактальная размерность. Все разнообразие статистич. свойств случайного сигнала, порождаемого динамик. системой об С. а., может быть описано, если известно распределение вероятности состояний системы. Однако получить (и использовать) это распределение для конкретных систем об С. а. чрезвычайно сложно (хотя бы потому, что плотность распределения инвариантной вероятностной меры всегда сингулярна). Это одна из причин, по к-рой для описания С. а. и сопоставления его свойств со свойствами реального сигнала используют разл. рода усредненные характеристики. Наиб. широко используемыми являются всевозможные размерностные характеристики, в частности фрактальная размерность (см. также [2-4])

$$\bar{c} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\ln N(\varepsilon)} [-\ln N(\varepsilon)/\ln \varepsilon], \quad (2)$$

где $\varepsilon > 0$, нек-рый фиксированный параметр, $N(\varepsilon)$ — число n -мерных шаров диаметра ε , покрывающих С. а. динамик. системы с n -мерным фазовым пространством. Определенная согласно ур-нию (2) размерность \bar{c} не может, очевидно, превышать n , но может быть меньше n (n -мерные шары могут оказаться почти пустыми). Для «обычных» множеств ур-ние (2) дает очевидные результаты. Так, для множества из k точек $N(\varepsilon) = k$, $\bar{c} = 0$; для отрезка длины L прямой линии $N(\varepsilon) \sim L/\varepsilon$, $\bar{c} = 1$; для куска площади S двумерной поверхности $N(\varepsilon) \sim S/\varepsilon^2$, $\bar{c} = 2$ и т. д. Неравенство размерности целому числу соответствует сложному геом. устройству. Для генератора, изображенного на рис. 1, размерность соответствующего аттрактора системы (1) в широком диапазоне изменения параметров остается заключенной в интервале (2,3 + 2,6).

С фаз. точки зрения, осн. «достоинство» фрактальной размерности С. а. в том, что она дает оценку эфф. числа степеней свободы, формирующих установившийся (после окончания всех переходных процессов) стохастич. сигнал. Более строгое соотношение между размерностью \bar{c} и числом степеней свободы m имеет вид: $m \leq (2\bar{c} + 1)$.

Бифуркации странных аттракторов. Пути рождения стохастич. автоколебаний при изменении управляющего параметра (напр., коэф. усиления в генераторе рис. 1) зависят от конкретных свойств исследуемой системы. Однако как и предельный цикл, к-рый может родиться лишь несколькими типичными способами, так и С. а. обладают сравнительно небольшим числом разл. типичных возможностей возникновения [1,4-6].

Сценарий Фейгенбаума — цепочка бифуркаций удвоения периода устойчивого предельного цикла. Если при изменении управляющего параметра периодич. движение теряет устойчивость, то вместо него может возникнуть др. устойчивое движение (напр., квазипериодическое, лежащее на притягивающем двумерном торе) либо предельный цикл удвоенного периода; последнему случаю соответствует переход мультипликатора через (-1). В n -мерном фазовом пространстве поведение траекторий отображения Пуанкаре в окрестности претерпевающего бифуркацию удвоения периода предельного цикла определяется ф-цией, напр., $f(x)$, график к-рой похож на параболу. Эта ф-ция описывает связь между координатами в направлении собств. подпространства оператора линеаризации отображения Пуанкаре, отвечающего мультипликатору (-1) ($j+1$ -го и j -го пересечения траекторий системы с текущей Пуанкаре: $x_{j+1} = f(x_j)$). Возникшему устойчивому предельному циклу удвоенного периода отвечает двумерный траектория отображения f . При дальнейшем изменении параметра бифуркация удвоения периода бесконечно повторяются, а бифуркац. значения, напр., λ_n накапливаются к критич. точке λ_∞ , отвечающей возникновению С. а. В соответствии со сценарием Фейгенбаума имеет место универсальный (не зависящий от конкретной системы) закон

$$(\lambda_\infty - \lambda_n)/(\lambda_\infty - \lambda_{n+1}) \sim \delta,$$

где $\delta = 4,6692... —$ универсальная константа Фейгенбаума (см. Фейгенбаум *универсальность*).

Родинамус С. а. при фиксированном $\lambda > \lambda_\infty$ отвечает нек. интервалом на оси λ ; участки между этими интервалами содержат притягивающиеся к аттрактору траектории, а также 2^m -периодические (относительно отображения f), неустойчивые предельные циклы, начиная с нек-рого m_0 и меньше. При увеличении параметра λ скорость разбегания траекторий на С. а. увеличивается, и он «разбухает», последовательно поглощая неустойчивые предельные циклы периодов 2^{m+1} , $2^m, \dots$ При этом число отрезков, отвечающих аттрактору, уменьшается, а их длины увеличиваются. Возникает как бы обратный каскад последоват. упрощений аттрактора. Рис. 6 иллюстрирует этот процесс для

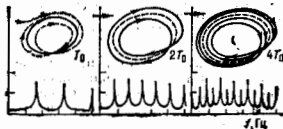


Рис. 6. «Обратные» бифуркации удвоения периода, иллюстрирующие разбухание аттрактора, возникшего по сценарию Фейгенбаума.

двух последних бифуркаций. На рис. 6а «лента» аттрактора совершает 4 оборота, после бифуркации она становится двухоборотной и затем, после следующей бифуркации, замыкается на себя всего через один оборот, предварительно перекрутившись (6б и 6в).

Перемена жесткости. Во мн. системах при прохождении управляющего параметра (скажем, λ) через бифуркац. значение λ_c переход к стохастич. автоколебаниям внешне осуществляется как редкое нарушение регулярных колебаний стохастич. всплесками. При этом длительность ламинарной (регулярной) фазы тем больше, чем меньше надкритичность $\lambda - \lambda_c > 0$. С ростом же надкритичности длительность регулярной фазы сокращается. Эта картина интерпретируется следующей эволюцией осн. объектов в фазовом пространстве, определяющих бифуркации (предельные циклы, сепаратрисы седловых периодич. траекторий и пр.). В момент бифуркации сливаются и исчезают отвечающий автоколебаниям устойчивый предельный цикл и седловая периодич. траектория. При малой надкритичности все траектории, стремившиеся ранее к устойчивому предельному циклу, долгое время сохраняют характер своего поведения, т. е. демонстрируют движение, близкое к периодическому. С течением времени $[\lambda - \lambda_c]^{-1/2}$ они «замечают», что старый аттрактор исчез, и, оставаясь рядом с сепаратрисой (также исчезающей) седлового предельного цикла, уходят в др. часть фазового пространства. Если в докритич. области система была глобально устойчива (т. е. существовал только один притягивающийся объект), то эти траектории через нек-рое время вновь попадают в окрестность исчезнувшего предельного цикла. Если при этом в докритич. области значений параметров сепаратриса седлового цикла была вложена в фазовое пространство достаточно сложным геом. образом (образованная бесконечное число складок — «гофрированная», содержала гетероклич. траектории др. седловых циклов и т. п.), то есть переходный процесс демонстрировал иерегулярное поведение, то время попадания в окрестность исчезнувшего цикла уже $\lambda > \lambda_c$ будет являться случайной величиной. Далее повторяется ламинарная фаза, предшествующая новому, «турбулентному», всплеску и т. д.

Кроме этих основных способов возникновения С. а. достаточно часто встречаются также переходы и хаотич. автоколебаниям через разрушение квазипериодических (в фазовом пространстве при изменении управляющих параметров теряет гладкость и разрушается притягивающий двумерный тор) и комбинированные сценарии [6].

Многомерные странные аттракторы часто обнаруживаются в системах с большим числом степеней свободы. Среди возможных механизмов, объясняющих существование многомерных С. а., выделяются следующие: 1) в многомерном фазовом пространстве в докритической ситуации существуют непритягивающее стохастическое множество и маломерный С. а. В момент бифуркации маломерный аттрактор перестает быть таковым, а бывшее непритягивающее стохастическое множество высокой размерности вливается в возникший жестким образом (скачком) многомерный аттрактор; 2) при изменении параметров в аттракторе происходит постепенная непрерывная перестройка его структуры, при к-рой размерности аттрактора монотонно увеличивается. Здесь можно выделить два случая: а) при изменении параметра в аттракторе рождаются седловые траектории со всё большим числом неустойчивых направлений; б) число неустойчивых направлений сохраняется, но возрастает скорость разбегания траекторий вдоль этих направлений. Стохастиче. автоколебания распределенных систем (с бесконечномерным фазовым пространством) имеют много общего с движением динамических диссипативных систем, описываемых системами конечного числа обыкновенных дифференц. ур-ий. Связь эта объясняется действием высокочастотной диссипации (в гидродинамике, напр., это — вязкость). Такая диссипация лишает маломасштабные возмущения среды самостоятельности, в результате чего описываемые их движение ф-ции начинают алгебраически зависеть от соответствующих ф-ций, отвечающих крупномасштабным возмущениям. Т. о., реально движение бесконечномерной системы описывается траекториями, лежащими на конечноморном (хотя, возможно, высокой размерности) С. а.

Неупорядоченное течение в области перехода к турбулентности также представляет собой движение на С. а. (см. *Турбулентность*).

Лит.: 1) Рабинович М. И., Трубицной Л. И., Введение в теорию колебаний и волн, М., 1984; 2) Лихтенберг А., Либерман М., Регулярная и стохастическая динамика, пер. с англ., М., 1983; 3) Абрамзон В. С., Рейман А. М., Распределение и эволюция многомерных систем, в кн.: Немонные волны. Динамика и эволюция, под ред. А. В. Гапонова-Грехова, М. И. Рабиновича, М., 1988; 4) Шустер Г., Детерминированный хаос. Введение, пер. с англ., М., 1988; 5) Ли в ян Л. Д., Ли в ян В. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; 6) Абрамзон В. С., Внутренние бифуркации и кризисы аттракторов, в кн.: Нелинейные волны. Структуры и бифуркации, под ред. А. В. Гапонова-Грехова, М. И. Рабиновича, М., 1987; 7) Гидродинамические неустойчивости и переход к турбулентности, под ред. Х. Сунгина, Дж. Голлаба, пер. с англ., М., 1984; 8) Рабинович М. И., Судик М. И., Регулярная и хаотическая динамика структур в течениях жидкости, «УФН», 1993, т. 160, с. 3.

В. С. Абрамзон, М. И. Рабинович.

СТРАТОСФЕРА — слой атмосферы между тропосферой и мезосферой. Нижняя граница С.— тропопause — расположена в полярных и умеренных широтах на высоте $z \approx 8-12$ км, в тропиках — на $z \approx 16-18$ км. От зимы к лету тропopause поднимается в ср. на 1—2 км. Верхняя граница С.— стратopause — находится на $z \approx 50-55$ км. Хим. состав воздуха в С. в осн. состоит из N_2 (с объёмной концентрацией 78,08%) и O_2 (20,95%). Из-за низких темп-р массовое отношение влаги в С. $m \approx 2 \cdot 10^{-6}$, т. е. очень мало. Благодаря фотохим. процессам в С. образуется слой озона O_3 . Поглощая большую часть излучения Солнца с $\lambda < 360$ нм (максимум поглощения соответствует $\lambda \approx 255$ нм), этот слой образует щит, предохраняющий живые организмы от ультрафиолетового радиация (УФР), разрушающей ДНК. Большая часть O_3 расположена на $z \approx 10-50$ км (в т. л. озоносфере). Общее кол-во O_3 в столбе атмосферы измеряется толщиной Х того слоя, к-рый образовался бы, если выдуть весь O_3 и привести его к давлению 1013,2 мбар (760 мм рт. ст.) в темп-р 0°С. Значения Х колеблются от 1 до 6 км. Во все сезоны в С. Северного полушария содержание O_3 больше, чем в С. Южного, а в С. высоких широт O_3 больше полшарий больше, чем в С. низких.

Макс. кол-во O_3 в С. умеренных широт содержится на $z \approx 20-22$ км, в тропиках — на $z \approx 26-27$ км. В 1980-е гг. обнаружено резкое уменьшение кол-ва O_3 (т. л. озоновая дыра) над Антарктидой. Уменьшение O_3 , хотя и меньшее, чем в Антарктике, зарегистрировано в ряде районов Северного полушария. Это явление в осн. обусловлено разрушением O_3 попадающими в С. пром. хлорфторуглеродами, особенно фреонами.

Темповой режим С. в осн. определяется лучистым теплообменом, в меньшей степени — вертикальными движениями и горизонтальным переносом воздуха. В целом С. близка к лучистому равновесию, т. е. темп-ра T в ней соответствует равенству энергии, поглощаемой и излучаемой молекулами H_2O , CO_2 и O_3 . Поглощение УФР молекулами O_3 приводит к росту темп-ры в С. Из-за того, что большая часть УФР поглощается O_3 на высоте ≈ 35 км, темп-ра в верх. части озоносферы поднимается до 0°С. Радиационное охлаждение в осн. обусловлено ИК-излучением CO_2 и в меньшей степени H_2O и O_3 . В умеренных и высоких широтах T в ниж. половине С. мало меняется с высотой, а выше — растёт. В тропиках T растёт с высотой по всей толще С. Из-за такого распределения T С. термодинамически устойчива по отношению к вертикальным турбулентным перемещениям воздуха. В большинстве случаев у основания С. в умеренных и высоких широтах $T \approx 240-220$ К, а в тропиках 190—200 К. На верх. границе С. чаще всего $T \approx 270 \pm 10$ К.

Зимой по всей С. преобладают западные, летом — восточные ветры. Наб. скорости ветра чаще всего наблюдаются вблизи стратopause: они максимальной зимой и иногда достигают 100—200 м/с. Зимой и весной в С. преобладают $z \approx 31-42$ км; периодичность возникает внезапные потепления до 40—50 К, сопровождающиеся резким усилением ветра. Зоны потепления обычно перемежаются к востоку, постепенно ослабая при этом. Продолжительность потеплений достигает 40—50 сут. Сильные потепления (наблюдаются не каждый год) захватывают всю С. и сопровождаются сменой западных потоков на восточные. Слабые потепления локализуются в отд. слоях С. и не сопровождаются сменой западных ветров на восточные.

На $z \approx 20-30$ км иногда образуются т. л. перламутровые облака, состоящие, по-видимому, из кристалликов льда или переохлаждённых капель воды. Нижняя С. на z до 20—25 км отличается повыш. содержанием аэрозольных частиц, особенно сульфатных, заносимых сюда при вулканич. извержениях. Они сохраняются здесь дольше, чем в тропосфере, из-за слабости турбулентного обмена в С. и отсутствия вымывания осадками. Аэрозоли, увеличивая атмосферное альбедо, вызывают понижение темп-ры у земной поверхности, особенно сильно после больших извержений вулканов.

Лит.: Хргиан А. Х., Физика атмосферы, М., 1986; Травянко Д. А., Структура и циркуляция стратосферы и мезосферы Северного полушария, Л., 1988. С. М. Шметер.

СТРАТЫ (от лат. stratum — настил, слой) — неоднородные или движущиеся зоны неравномерной светимости, регулярно чередующиеся с тёмными промежутками в положительном столбе газового разряда низкого давления, напр. *тающего разряда*. Обычно яркой стороной С. обращены к катоду. С. бывают неподвижные и движущиеся, причём движущие они также от анода к катоду. В однородных трубках, в чистых инертных газах С. движутся со скоростями порядка десятков м/с при давлении $p \approx 10^{-4}-10^{-3}$ торр. Напряжённость электрич. поля, плотность и темп-ра электронов на фронте С. обычно высоки (визуально — светлый слой). При удалении от фронта к аноду напряжённость поля, темп-ра и плотность электронов уменьшаются настолько, что ионизация прекращается (повляется тёмный промежуток).

По совр. представлениям, С. представляют собой *ионизационные волны*; в случае небольших pd (d — межэлектродное расстояние) это — *ливневая волна*, воз-

никающая в ограниченном пространстве (газоразрядной трубке). (Заметим, что в свободном пространстве волны ионизации в разрядах проявляются в виде *стримеров*.) Длина одной С., т. е. расстояние между соответствующими точками соседних С., составляет неск. диаметров трубки.

Т. к. движущиеся С. — волновой процесс, то гл. роль в их возникновении играют пространственные неоднородности продольного типа. В молекулярных газах пространственный масштаб неоднородности, определяемый длиной установления электронной температуры a , весьма мал вследствие большой скорости передачи энергии от электронов молекулам. Поэтому и возможные неоднородности могут быть весьма мелкими. В атомарных инертных газах, где передача энергии крайне замедлена и длина a велика, движущиеся С. — типичный процесс. Схема, поясняющая причину движения С. от анода к катоду, дана на рис. 1. В реальных,

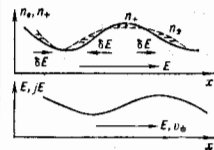


Рис. 1. Схема, поясняющая причину движения стримера от анода к катоду.

сравнительно коротких волнах градиенты плотности значительны. Для таких волн распределения электронной n_e (штриховая линия) и ионов n_+ (сплошная кривая) соответствуют преобладанию диффузии электронов над дрейфом. Возникающее поле поляризации δE складывается с постоянным невозмущающим полем E на том участке волны, где n_e уменьшается в сторону падения потенциала, и вычитается из E на другом склоне. По этой причине волна δE сдвигается на четверть длины волны в сторону катода относительно волны δn_e . Это приводит к смещению максимума скорости ионизации, т. е. возбуждается волна ионизации.

На рис. 2 приведены эксперим. и теоретич. данные о зависимости длины волны С. λ от частоты поля ν для разряда в аргоне при $p = 60$ Па и токе 3,6 А в трубке

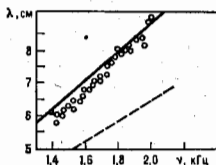


Рис. 2. Зависимость длины волны стримера от частоты.

радиусом 1,65 см. Фазовая скорость С. изменялась от 80 до 180 м/с; групповая скорость С. $v_{гр} = d\omega/dk < 0$, т. е. направлена противоположно фазовой, что является особенностью С. в электрич. разряде.

В С. большой амплитуды ф-ция распределения электронов может иметь молекулярный характер, что резко усложняет теоретич. описание появления С.

Лит.: Давид П. С., Автоколебания в распределенных системах. М., 1983; Райзер В. А., Физика газового разряда. М., 1987; Рожаксис В. А., Целив Л. П., Столкновительный перенос в частично-ионизованной плазме. М., 1988.

Э. И. Асиновский.

СТРИМЕРНАЯ КАМЕРА — разновидность *искровой камеры*, в к-рой разряд, вызванный импульсом высокого напряжения, образуется на стримерной стадии *искрового разряда*. С. к. представляет собой заполненный газом объем, содержащий плоскопараллельные электроды. После прохождения заряд. частицы, вызвавшей

ионизацию газа вдоль траектории, на эти электроды подается короткий импульс высокого напряжения, длительностью 12—20 нс, что обеспечивает прекращение развития разряда. Начальная стадия разряда — электронные лавины, переходящие в *стримеры* (положительный и отрицательный) — узкие светящиеся каналы, га в к-рых ионизован. Фронт стримера движется со скоростью до 4·10⁸ м/с в полях ~ 30 кВ/см. Стримеры формируются вдоль электрич. поля, стартова от электронов начальной ионизации и обрывается на длине в неск. мм. Стримеры, являющиеся самосветящимися объектами, фотографируются и после обработки фотопластики по ней определяют координаты треков частиц. Впервые С. к. создана в 1963 Г. Е. Чиковани с сотрудниками и независимо В. А. Долгошеиным с сотрудниками [1]. Чаще всего С. к. используют как *мгновенные спектрометры* с мишенью, расположенной в их объеме. С. к. можно изучать взаимодействие частиц в газе, заполняющем камеру, а также в мипных из разных материалов, расположенных перед С. к. или в объеме камеры. С. к. управляема — отбор событий осуществляется при помощи электронных детекторов. Она имеет малое время памяти ($\sim 0,5$ —1 мкс), может работать в пучках высокой интенсивности ($\sim 10^8$ частиц/с) и способна регистрировать до 10⁸ частиц в 1 с. По контрастности изображения и разрешающей способности С. к. уступают *пузырьковым камерам*, однако управляемость позволяет использовать их для исследования процессов, имеющих малые вероятности. Мертвое время С. к. составляет 10⁻⁴ с. Иногда вместо фотографирования применяют съем информации с помощью телекамер или *приборов с зарядовой связью* (ПЗС). Использование ПЗС позволяет увеличить быстрдействие прибора, а также значительно сокращает время обработки, т. к. информация с ПЗС непосредственно подается в ЭВМ.

Обычно С. к. имеют размеры 1 × 0,5 × 0,5 м² (одна из самых больших И. к. имеет длину 8 м). В качестве газа используют Не, Ne₂, смесь Ne + He, He + CH₄, D₂ + CH₄ при давлении $p = 1$ атм. Импульсные напряжения ~ 20 кВ/см. При $p = 1$ атм С. к. имеют нулевое координатное разрешение, связанное со значит. размером стримеров (диаметр ~ 1 мм, длина ~ 5 мм) и малой их плотностью (~ 10 —12 см⁻¹).

Улучшения пространственного разрешения можно достичь, регистрируя не свечение стримера, а рассеяние света на оптич. неоднородностях в стримерных каналах при освещении их лазерным источником. Выделившись в канале джоулево тепло и расширение стримера со сверхзвуковой скоростью вызывают уменьшение плотности газа и, следовательно, уменьшение показателя преломления в канале. Подсветка стримера лазером производится после окончания высоковольтного импульса и по истечении времени, в течение к-рого электроны передают свою энергию тяжелым частицам в стримерном канале (ионам, атомам, молекулам). Обычно это время $t \sim 5$ —100 нс для легких газов и $t \sim 200$ —500 нс — для тяжелых. Длительность лазерного импульса ~ 1 —30 нс. Обычно подсветка осуществляется вдоль электрич. поля (полупрозрачные или сетчатые электроды), поэтому треки частицы на фотопленке фиксируются в виде последовательности точек. Внеш. подсветка не только улучшает координатное разрешение между треками из-за меньших размеров объектов (видна только сердцевина стримера — керн, с макс. оптич. неоднородностью), но и увеличивает плотность л стримерных изображений (регистрируются каналы со слабым свечением).

Дальнейшее улучшение пространственного разрешения связано с голографич. съемом информации при освещении С. к. импульсным лазером. При этом возможна более точная локализация трека, т. к. изро изображения элементов трека в голограмме значительно меньших размеров, чем в изображении того же элемента на обычной фотографии (табл.). При обработке

возможным является возможность восстанавливать трёхмерное изображение трека (см. Голография [2]).

Характеристики методов регистрации в стримерных камерах (He (70%) + Ne (30%), $p = 1$ атм.)

Метод регистрации	Размеры стримера, мм		σ^* , мм	δ^* , мм	η , см ⁻¹
	поперек поля	вдоль поля			
Фотография	6,2	1,53	0,240	0,021	2,5
Голография	2,5	0,39	0,195	0,011	8,2

Примечание. * σ — среднеквадратичное отклонение центров стримеров от трека; ** δ — точность локализации трека.

Улучшение координатного разрешения можно достичь в С. к. высокого давления, т. е. размеры лавины с увеличением p уменьшаются. Диффузия электронов до подачи импульса, определяющая разброс центров стримеров от трека, также уменьшается с увеличением давления $\propto 1/\sqrt{p}$. В миниатюрных С. к. высокого давления размером $40 \times 40 \times 5$ мм³, работающей на смеси Ne (90%) + He (10%) при $p = 20$ атм, получены стримеры diam. 50 мкм, при $\sigma \approx 15$ мкм, ширине трека ~ 100 мкм, $\eta = 2-4/\text{мм}$ [3]. Напряжённость электрич. поля в таких С. к. достигает 330 кВ/см. Регистрации треков обычно ведётся с помощью электронно-оптических преобразователей, световой сигнал с к-рого через волоконный световод попадает на фотопленку. Благодаря малым размерам камеры и небольшому изображению на фотопленке достигается повышенная разрешающая способность.

Недостаток С. к. высокого давления с высоким разрешением — малая глубина резкости. Для обычной оптич. системы глубина резкости R и разрешение R связаны соотношением $R = 0,6\sqrt{\lambda D}$, где λ — длина световой волны. При разрешении объектов размером 20 мкм $D = 2$ мм. Для голографич. съёма информация глубина голографирования $D \approx l_0 (d/\lambda)^2/12$, где d — диаметр объекта, l_0 — длина когерентности. Для лазерного излучения l_0 может составлять несколько см. При $d = 20$ мкм $\lambda = 0,5$ мкм, $l_0 = 1$ см, $D = 1,3$ м. Т. о., голографич. съём информации увеличивает глубину резкости, а также позволяет увеличить загрузку С. к. в 10–100 раз за счёт равномерного распределения частиц по глубине камеры. Для С. к. высокого давления (13 атм) диаметром 50 мм и толщиной 23 мм, работающей на смеси Ne (90%) + CH₄ (10%), было получено разрешение 25 мкм, что соответствует диаметру стримера [4].

Лит.: 1) Chikovani G. E., Roinishvili V. N., Mikhalov V. A., Operation mechanism of the track spark chamber, «Nucl. Instr. and Meth.», 1984, v. 29, p. 241; 2) Варте Е., Иванов И. С., Применение голографии в трековых детекторах в трёхмерном пространственном разрешении, «ЭЧАЯ», 1986, т. 17, в. 3, с. 546; 3) Dine M. и др., Search for short-lived particles using a high-resolution streamer chamber, «FNAL proposal», 1976, 24-490; Sandweiss J., The resolution streamer chamber, «Physics Today», 1978, October issue, p. 40; 4) Eckardt V., Wenig S., Development of a small high pressure streamer chamber for short-life time measurements, «Nucl. Instr. and Meth.», 1983, v. 213, p. 217; 5) Eckardt V. et al., A holographic high pressure streamer chamber, «Nucl. Instr. and Meth.», 1984, v. 223, p. 851. С. В. Головкин.

СТРИМЕРНЫЕ ТРУБКИ (дрейфовые трубки) — система газоразрядных детекторов, используемая для регистрации и измерения координат точек траектории быстрых ионизирующих частиц. С. т. длиной до нескольких м изготавливают из тонкостенных круглых металлических трубок или профилей, пластика с каналами прямого сечения. В центре каждой трубки или канала натягивается анодная проволочка диаметром 40–200 мкм, катодом служат проводящие стенки С. т. Рядус С. т. (размер межэлектродного промежутка) обычно составляет ок. 1 см.

Под действием ионизирующих частиц в С. т. образуется импульсный самогасящийся стримерный раз-

ряд, в результате чего на анодной проволочке возникает токовый сигнал, амплитуда к-рого (~ 1 мА) значительно выше, чем в пропорциональных детекторах (см. Пропорциональный счётчик). Амплитуда сигнала не зависит от ионизирующей способности частицы (её флукутация $\leq 40\%$). В то же время, в отличие от Гейгера счётчика, ряд С. т. локализован и определ. трубки, что позволяет с высокой точностью измерить координаты точки прохождения частиц. Подобный характер разряда обеспечивается опред. составом и давлением газа, а также величиной падающего напряжения (обычно 4–6 кВ). Обычно применяют смесь инертного газа (Ar) с углеводородом (или чистым углеводородом) при обязат. добавках 10–20% паров сложных органич. соединений (металла, спирта, эфира, n -пентана или их комбинаций). Последние, обладая большим сечением поглощения УФ-фотонов, высвечиваемых при развитии разряда, способствуют его локализации вдоль нити. Эффективность С. т. (вероятность регистрации частицы) в области плато счётной характеристики близка к 100%.

Координаты точки прохождения ионизирующей частицы через С. т. в направлении, поперечном анодной нити, определяются по времени дрейфа электронов в газе, т. е. развитие стримерного разряда происходит намного быстрее. При этом начало отсчёта задаётся сигналом триггера, а стоп-сигналом служит выходной импульс С. т. Координатное разрешение С. т. составляет 0,1–0,5 мм, временное — 100–200 нс. Точность координатных измерений в направлении вдоль анодной проволочки приближается к 1 см.

Благодаря постоянной чувствительности, большой амплитуде, стандартной форме сигнала, высокой загрузочной способности, стабильности, высоким координатному и временному разрешениям, С. т. находят применение в комбинированных системах детекторов, используемых в экспериментальной ядерной физике и физике частиц высоких энергий, а также при исследовании космических лучей.

Лит.: Алексеев Г. Д., Круглов В. В., Хазис Д. М., Самогасящийся стримерный (СГС) разряд в проволочной камере, «ЭЧАЯ», 1982, т. 13, в. 3, с. 703; Труды Международного симпозиума по координатным детекторам в физике высоких энергий, Дубна, 1982. И т. а и др. Детекторы корпускулярных излучений, пер. с нем., М., 1980. Г. И. Мерзон.

СТРИМЕРЫ (англ. stream — поток), также светящиеся каналы ионизованного газа, возникающие в предпробойной стадии коронного или искрового разряда в случае больших pd (p — давление, d — межэлектродное расстояние). Переход, ярко светящаяся часть ионизованного канала называется головкой С. В зависимости от направления движения головки С. различают катодный и анодный С. Стримерная стадия пробоя газа занимает промежуточное положение между лавинной и искровой. При малых pd лавинная стадия пробоя может сразу перейти в искровую, минуя стадию С. (см. Пробой газа).

Характерным отличием С. от лавины электронной является высокая скорость распространения его головки к катоду или аноду ($\sim 10^6$ м/с), значительно превосходящая дрейфовую скорость электронов во внешнем электрич. поле. Скорость катодного С. при атм. давления и $d = 1$ см примерно на два порядка превосходит скорость лавины. Это служит основанием для выделения С. как самостоятельной предпробойной стадии. Переход лавины в С. наблюдался Г. Петером (H. Raether, 1962) в спец. экспериментах с камерой Вильсона. Л. Лёб (L. Loeb) и Дж. М. Мик (J. M. Meek), а также независимо от них Петер предложил стримерную модель для объяснения высокой скорости формирования самостоятельного разряда. Высокая скорость движения головки С. объясняется действием двух факторов. Во-первых, газ перед головкой С. возбуждается резонансным излучением, что приводит к появлению

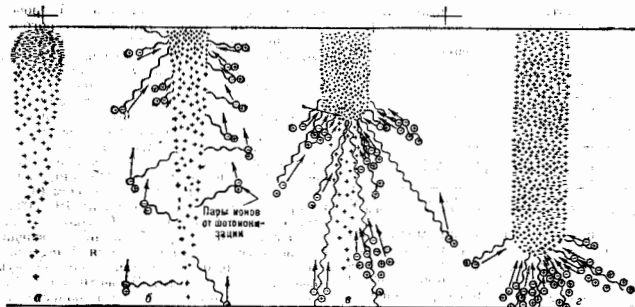
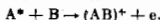


Схема развития катодного стримера.

свободных (затравочных) электронов в реакции ассоциативной ионизации



(Этот канал образования затравочных электронов существенно более эффективен, чем прямая фотоионизация газа.) Во-вторых, существует сильное электрич. поле, создаваемое пространственным зарядом вблизи головки С., превосходящее ср. поле в промежутке и тем самым обеспечивающее высокую скорость ионизации на фронте распространения.

На рис. дана схема развития катодного С. После того, как головка электронной лавины достигнет анода (рис. а), в межэлектродном пространстве остаётся облако ионов. Дочерние лавины, возникающие в результате фотоионизации газа (рис. б), вливаются в облако положительного заряда. Увеличение плотности заряда приводит к развитию самораспространяющегося потока положительных зарядов (рис. в, г) — стримера. Предполагается, что в момент перехода лавины в С. в лек-рой тонке на оси лавины обращается в нуль результирующее поле (внешнее и поле пространственного заряда лавины).

По совр. представлениям, фронт С. представляет собой нелинейную волну ионизации, волну пространств. заряда, возникающую в свободном пространстве и аналогичную волне горения, волнам в биологически активных средах и т. п. (см. Ионизационные процессы, А. В. Иванов).

Для катодного С. большое влияние на формирование фронта оказывает выход излучения из межэлектродного промежутка.

При достижении в головке С. критич. значения поля, соответствующего началу убегающих электронов (см. Убегающие электроны), нарушается локальное равновесие между электрич. полем и распределением электронов по скоростям. Этот факт значительно усложняет модель С.

Лит.: Лав Л., Основные процессы электрических разрядов в газах, пер. с англ., М.—Л., 1950; Петер Г., Электронные лавины и пробой в газах, пер. с англ., М., 1968; Лозанский Э. Д., Фирсов О. В., Теория искры, М., 1975; Свиридов Ю. М., Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии, М., 1987; Лагарьянов А. М., Руткевич И. М., Волны электрического пробоя в ограниченной плазме, М., 1989.

—Э. И. Асимовский.

Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д: М. Алексеев, А. М. Балдин, А. М. Бочк-Бруевич, А. С. Боровик-Романов и др. — М.: Большая Российская энциклопедия. Т. 4 Пойнтинга—Робертсона—Стримеры 1994. 704 с., ил.

ISBN 5 — 85270 — 087 — 8 (т. 4)
ISBN 5 — 85270 — 034 — 7

Ф 380200000—014
007 (01) — 94 подписное

53(03)

ИБ № 226

Лицензия № 010144 от 24.12.91. Сдано в набор 1.04.92. Подписано в печать 19.02.93. Формат 84×108 1/16. Бумага типографская №1. Гарнитура обыкновенно-нован. Печать высокая. Усл. печ. л. 73,92; уч.-изд. л. 122,67; усл. ир.-отт. 74,76. Тираж 40 000 экз. Заяв. № 55. С 5.

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 109817, г. Москва, Покровский бульвар, д. 8.

Московская типография № 2 Комитета Российской Федерации по печати, 129301, г. Москва, Проспект Мира, д. 105.